2026 年 2 月发布最新 《薄膜芯片滤波器产品手册》 ，涵盖带通、高通、低通，在 2025 年 2 月发布的 741 款的基础上新增近 180 款，现达到 920 余款，非本产品手册的型号会逐步停产，请以本产品手册为准。查找现货请登陆 www.dianzibuy.com 查看，明码标价，诚信经营，采购数量越多折扣越多，自动计算折扣，商城数量实时更新，真实库存，1~2 个工作日发货。更多产品登陆公司官网 www.com-mw.com 查看。

目录

带通滤波器	STBP2R7-1R8-N032（1.8-3.6GHz）	（1）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP2R6-1R0-N215（2.05-3.05GHz）	（2）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP2R5-0R6-M620（2.2-2.8GHz）	（3）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP2R8-1R2-N055（2.25-3.35GHz）	（4）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP2R5-0R4-M516（2.3-2.7GHz）	（5）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP2R5-0R1-M520（2.45-2.55GHz）	（6）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP2R5-0R0-M518（2.48GHz）	（7）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP2R9-0R5-K448（2.6-3.1GHz）	（8）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP2R8-0R2-N509（2.65-2.85GHz）	（9）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP2R7-0R0-M515（2.7GHz）	（10）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP3R6-1R8-M475（2.7-4.5GHz）	（11）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP4R2-3R0-M483（2.7-5.7GHz）	（12）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP4R6-3R8-M474（2.7-6.5GHz）	（13）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP2R9-0R2-N508（2.75-2.95GHz）	（14）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP2R9-0R2-N507（2.8-3.0GHz）	（15）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP3R4-1R2-N047（2.8-4.0GHz）	（16）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP2R9-0R1-M519（2.85-2.95GHz）	（17）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP3R4-1R0-K972（2.9-3.9GHz）	（18）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP3R6-1R4-M621（2.9-4.3GHz）	（19）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP3R9-1R9-M580（2.9-4.8GHz）	（20）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP3R0-0R1-M633（2.92-3.02GHz）	（21）	点此查看规格书

电话：(+86)156 0809 5669　　邮箱：sales@com-mw.com
传真：(+86)028 8408 5893　　地址：四川省成都市成华区航天路118号4-3单元

微信扫码联系

带通滤波器	STBP3R0-0R0-M517（3GHz）	（22）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP3R0-0R0-K725（3GHz）	（23）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP3R4-0R8-M446（3.0-3.8GHz）	（24）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP3R3-0R4-N353（3.05-3.45GHz）	（25）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP3R1-0R0-K270（3.1GHz）	（26）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP3R5-0R8-M643（3.1-3.9GHz）	（27）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP3R9-1R6-M637（3.1-4.7GHz）	（28）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP3R5-0R4-K449（3.3-3.7GHz）	（29）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP3R7-0R7-M560（3.3-4.0GHz）	（30）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP4R0-1R3-N048（3.3-4.6GHz）	（31）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP3R4-0R0-K269（3.35GHz）	（32）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP3R5-0R1-M632（3.4-3.5GHz）	（33）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP4R0-1R2-K974（3.4-4.6GHz）	（34）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP4R0-1R0-K973（3.5-4.5GHz）	（35）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP4R2-1R4-N056（3.5-4.9GHz）	（36）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP3R6-0R0-K271（3.6GHz）	（37）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP4R3-1R4-K405（3.6-5.0GHz）	（38）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP4R0-0R1-K726（3.9-4.0GHz）	（39）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP4R4-1R0-M561（3.9-4.9GHz）	（40）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP5R7-3R7-M428（3.9-7.6GHz）	（41）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP4R0-0R1-M634（3.91-4.01GHz）	（42）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP4R2-0R4-N296（4.0-4.4GHz）	（43）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP4R2-0R4-K450（4.0-4.4GHz）	（44）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP4R4-0R7-N051（4.0-4.7GHz）	（45）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP4R5-1R0-M644（4.0-5.0GHz）	（46）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP5R0-2R0-M447（4.0-6.0GHz）	（47）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP4R4-0R5-K975（4.05-4.65GHz）	（48）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP4R1-0R0-K272（4.1GHz）	（49）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP4R4-0R5-N297（4.1-4.6GHz）	（50）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP4R9-1R6-N540（4.1-5.7GHz）	（51）	点此查看规格书

电话：(+86)156 0809 5669　　邮箱：sales@com-mw.com
传真：(+86)028 8408 5893　　地址：四川省成都市成华区航天路118号4-3单元

微信扫码联系

带通滤波器 STBP4R8-1R2-N049（4.2-5.4GHz） ..... （52） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP4R9-1R2-K976（4.25-5.45GHz） ..... （53） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP4R6-0R5-N298（4.3-4.8GHz） ..... （54） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP5R4-2R1-M631（4.3-6.4GHz） ..... （55） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP4R5-0R1-M635（4.4-4.5GHz） ..... （56） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP4R7-0R4-M265（4.45-4.85GHz） ..... （57） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP4R8-0R6-N307（4.5-5.1GHz） ..... （58） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP5R2-1R3-M669（4.5-5.8GHz） ..... （59） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP4R6-0R0-K273（4.6GHz） ..... （60） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP5R0-0R7-N308（4.6-5.3GHz） ..... （61） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP5R0-0R8-M502（4.6-5.4GHz） ..... （62） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP5R7-1R8-K509（4.8-6.6GHz） ..... （63） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP5R0-0R1-M636（4.9-5.0GHz） ..... （64） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP5R6-1R4-N050（4.9-6.3GHz） ..... （65） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP5R7-1R6-K977（4.9-6.5GHz） ..... （66） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP6R1-2R3-K778（4.9-7.2GHz） ..... （67） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP6R4-3R0-K569（4.9-7.9GHz） ..... （68） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP5R0-0R1-K727（4.95-5.05GHz） ..... （69） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP4R4-0R8-N057（4.95-5.75GHz） ..... （70） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP5R5-0R9-M645（5.0-5.9GHz） ..... （71） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP5R5-1R0-K602（5.0-6.0GHz） ..... （72） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP5R5-1R0-K819（5.0-6.0GHz） ..... （73） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP5R8-1R5-K503（5.0-6.5GHz） ..... （74） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP6R1-2R1-K289（5.0-7.1GHz） ..... （75） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP6R2-2R4-K252（5.0-7.4GHz） ..... （76） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP5R5-0R6-N337（5.2-5.8GHz） ..... （77） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP6R6-2R8-K634（5.2-8.0GHz） ..... （78） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP5R6-0R5-N544（5.3-5.8GHz） ..... （79） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP5R8-0R9-M406（5.3-6.2GHz） ..... （80） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP5R4-0R0-K274（5.4GHz） ..... （81） 点此查看规格书

电话：(+86)156 0809 5669 邮箱：sales@com-mw.com
传真：(+86)028 8408 5893 地址：四川省成都市成华区航天路118号4-3单元

微信扫码联系

带通滤波器	STBP5R5-0R0-N354（5.5GHz）	（82）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP6R6-2R0-K830（5.6-7.6GHz）	（83）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP7R0-2R6-K669（5.7-8.3GHz）	（84）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP7R9-4R3-N328（5.7-10.0GHz）	（85）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP6R2-0R7-M582（5.8-6.5GHz）	（86）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP7R7-3R8-K567（5.8-9.6GHz）	（87）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP7R8-4R0-K715（5.8-9.8GHz）	（88）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP6R1-0R3-M463（5.9-6.2GHz）	（89）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP6R3-0R8-M549（5.9-6.7GHz）	（90）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP8R8-5R8-M661（5.9-11.7GHz）	（91）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP6R0-0R1-K728（5.95-6.05GHz）	（92）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP6R6-1R1-M646（6.0-7.1GHz）	（93）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP7R0-2R0-M668（6.0-8.0GHz）	（94）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP7R5-3R0-K742（6.0-9.0GHz）	（95）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP8R0-4R0-M430（6.0-10.0GHz）	（96）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP8R0-4R0-M442（6.0-10.0GHz）	（97）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP9R0-6R0-K844（6.0-12.0GHz）	（98）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP120-120-N469（6.0-18.0GHz）	（99）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP6R8-1R4-K657（6.1-7.5GHz）	（100）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP7R5-2R8-M444（6.1-8.9GHz）	（101）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP7R6-2R9-M557（6.1-9.0GHz）	（102）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP6R9-1R4-M670（6.2-7.6GHz）	（103）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP7R4-2R4-K779（6.2-8.6GHz）	（104）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP6R5-0R2-K572（6.4-6.6GHz）	（105）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP7R1-1R3-N216（6.4-7.7GHz）	（106）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP7R3-1R7-K846（6.4-8.1GHz）	（107）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP8R2-3R6-M630（6.4-10.0GHz）	（108）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP6R7-0R3-M464（6.5-6.8GHz）	（109）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP7R2-1R3-K820（6.5-7.8GHz）	（110）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP125-120-K267（6.5-18.5GHz）	（111）	点此查看规格书

电话：(+86)156 0809 5669　　邮箱：sales@com-mw.com
传真：(+86)028 8408 5893　　地址：四川省成都市成华区航天路118号4-3单元

微信扫码联系

带通滤波器 STBP9R1-5R0-M477（6.6-11.6GHz） ..... （112） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP7R4-1R4-K528（6.7-8.1GHz） ..... （113） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP7R8-2R2-K253（6.7-8.9GHz） ..... （114） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP7R8-2R2-M500（6.7-8.9GHz） ..... （115） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP7R0-0R3-M548（6.8-7.1GHz） ..... （116） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP7R3-0R8-K529（6.9-7.7GHz） ..... （117） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP8R2-2R6-K290（6.9-9.3GHz） ..... （118） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP7R0-0R1-K729（6.95-7.05GHz） ..... （119） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP8R0-2R0-M296（7.0-9.0GHz） ..... （120） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP8R5-3R0-M667（7.0-10.0GHz） ..... （121） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP9R7-5R4-K885（7.0-12.4GHz） ..... （122） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP9R5-5R0-K523（7.0-13.0GHz） ..... （123） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP137-134-N522（7.0-20.4GHz） ..... （124） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP7R2-0R2-M247（7.1-7.3GHz） ..... （125） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP7R7-1R0-M647（7.2-8.2GHz） ..... （126） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP8R8-3R2-K608（7.2-10.4GHz） ..... （127） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP7R7-0R7-M555（7.3-8.0GHz） ..... （128） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP8R1-1R5-N464（7.3-8.8GHz） ..... （129） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP8R2-1R8-K508（7.3-9.1GHz） ..... （130） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP8R0-1R2-K534（7.4-8.6GHz） ..... （131） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP9R6-4R4-K831（7.4-11.8GHz） ..... （132） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP8R0-0R9-M436（7.5-8.4GHz） ..... （133） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP9R4-3R8-K563（7.5-11.3GHz） ..... （134） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP9R5-3R8-K864（7.5-11.3GHz） ..... （135） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP9R5-4R0-K861（7.5-11.5GHz） ..... （136） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP9R6-4R1-K887（7.5-11.6GHz） ..... （137） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP100-4R9-M330（7.5-12.4GHz） ..... （138） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP8R2-1R1-K502（7.6-8.7GHz） ..... （139） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP8R3-1R3-K349（7.6-8.9GHz） ..... （140） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP8R3-1R4-K658（7.6-9.0GHz） ..... （141） 点此查看规格书

电话：(+86)156 0809 5669 邮箱：sales@com-mw.com
传真：(+86)028 8408 5893 地址：四川省成都市成华区航天路118号4-3单元

微信扫码联系

带通滤波器 STBP9R3-3R3-M373（7.6-10.9GHz） ..... （142） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP104-5R6-M703（7.6-13.2GHz） ..... （143） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP8R4-1R3-K635（7.7-9.0GHz） ..... （144） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP9R0-2R6-K780（7.7-10.3GHz） ..... （145） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP9R7-4R0-M348（7.7-11.7GHz） ..... （146） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP9R8-4R2-K590（7.7-11.9GHz） ..... （147） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP9R4-3R2-K589（7.8-11.0GHz） ..... （148） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP107-5R8-K597（7.8-13.6GHz） ..... （149） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP8R0-0R2-K441（7.9-8.1GHz） ..... （150） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP8R0-0R2-M248（7.9-8.1GHz） ..... （151） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP8R0-0R2-M429（7.9-8.1GHz） ..... （152） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP8R4-1R0-N496（7.9-8.9GHz） ..... （153） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP8R5-1R2-K570（7.9-9.1GHz） ..... （154） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP104-4R9-M641（7.9-12.8GHz） ..... （155） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP107-5R5-M577（7.9-13.4GHz） ..... （156） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP8R3-0R5-K340（8.0-8.5GHz） ..... （157） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP8R8-1R6-K350（8.0-9.6GHz） ..... （158） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP9R5-3R0-M458（8.0-11.0GHz） ..... （159） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP9R9-3R8-M485（8.0-11.8GHz） ..... （160） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP101-4R2-M731（8.0-12.2GHz） ..... （161） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP110-6R0-K568（8.0-14.0GHz） ..... （162） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP147-154-N523（8.0-22.4GHz） ..... （163） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP102-4R2-M671（8.1-12.3GHz） ..... （164） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP9R5-2R6-K254（8.2-10.8GHz） ..... （165） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP104-4R3-M729（8.2-12.5GHz） ..... （166） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP8R6-0R6-K341（8.3-8.9GHz） ..... （167） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP8R9-1R1-K525（8.3-9.4GHz） ..... （168） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP8R9-1R2-M648（8.3-9.5GHz） ..... （169） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP9R5-2R4-K642（8.3-10.7GHZGHz） ..... （170） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP9R9-3R2-M730（8.3-11.5GHz） ..... （171） 点此查看规格书

电话：(+86)156 0809 5669 邮箱：sales@com-mw.com
传真：(+86)028 8408 5893 地址：四川省成都市成华区航天路118号4-3单元

微信扫码联系

带通滤波器	STBP100-3R2-K643（8.3-11.7GHz）	.....	（172）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP9R1-1R6-M403（8.4-10.0GHz）	.....	（173）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP9R2-1R6-K351（8.4-10.0GHz）	.....	（174）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP9R3-1R8-K544（8.4-10.2GHz）	.....	（175）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP9R0-1R0-K501（8.5-9.5GHz）	.....	（176）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP9R1-1R0-N497（8.6-9.6GHz）	.....	（177）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP110-4R8-M511（8.6-13.4GHz）	.....	（178）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP8R8-0R2-M249（8.7-8.9GHz）	.....	（179）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP9R0-0R5-N329（8.7-9.2GHz）	.....	（180）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP103-3R0-K743（8.8-11.8GHz）	.....	（181）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP9R2-0R6-K342（8.9-9.5GHz）	.....	（182）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP9R7-1R5-K352（8.9-10.4GHz）	.....	（183）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP9R4-0R8-N377（9.0-9.8GHz）	.....	（184）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP9R6-1R2-N363（9.0-10.2GHz）	.....	（185）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP9R8-1R6-K656（9.0-10.6GHz）	.....	（186）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP105-3R0-M297（9.0-12.0GHz）	.....	（187）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP117-5R4-M431（9.0-14.4GHz）	.....	（188）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP9R4-0R5-N545（9.1-9.6GHz）	.....	（189）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP9R4-0R5-K803（9.1-9.6GHz）	.....	（190）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP110-3R7-M559（9.1-12.8GHz）	.....	（191）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP9R9-1R4-K636（9.2-10.6GHz）	.....	（192）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP113-4R2-K716（9.2-13.4GHz）	.....	（193）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP9R5-0R4-N133（9.3-9.7GHz）	.....	（194）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP9R7-0R7-K343（9.3-10.0GHz）	.....	（195）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP9R7-0R8-N498（9.3-10.1GHz）	.....	（196）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP100-1R4-N367（9.3-10.7GHz）	.....	（197）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP9R5-0R2-M497（9.4-9.6GHz）	.....	（198）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP101-1R4-K353（9.4-10.8GHz）	.....	（199）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP107-2R6-K291（9.4-12.0GHz）	.....	（200）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP107-2R6-K783（9.4-12.0GHz）	.....	（201）	点此查看规格书

电话：(+86)156 0809 5669　　邮箱：sales@com-mw.com
传真：(+86)028 8408 5893　　地址：四川省成都市成华区航天路118号4-3单元

微信扫码联系

带通滤波器	STBP9R6-0R2-M250（9.5-9.7GHz）	（202）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP100-1R0-K256（9.5-10.5GHz）	（203）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP100-1R0-M649（9.5-10.5GHz）	（204）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP101-1R1-M505（9.5-10.6GHz）	（205）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP117-4R3-N365（9.5-13.8GHz）	（206）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP114-3R6-K609（9.6-13.2GHz）	（207）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP105-1R8-N322（9.6-11.4GHz）	（208）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP120-4R8-K717（9.6-14.4GHz）	（209）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP101-0R6-K345（9.8-10.4GHz）	（210）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP106-1R6-K354（9.8-11.4GHz）	（211）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP126-5R5-M478（9.8-15.3GHz）	（212）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP100-0R2-N160（9.9-10.1GHz）	（213）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP107-1R5-M254（9.9-11.4GHz）	（214）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP101-0R1-N206（10.0-10.1GHz）	（215）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP105-1R0-N499（10.0-11.0GHz）	（216）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP109-1R8-K524（10.0-11.8GHz）	（217）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP110-2R0-M553（10.0-12.0GHz）	（218）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP115-3R0-M491（10.0-13.0GHz）	（219）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP120-4R0-K637（10.0-14.0GHz）	（220）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP125-5R0-K371（10.0-15.0GHz）	（221）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP140-8R0-M443（10.0-18.0GHz）	（222）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP118-3R3-M501（10.1-13.4GHz）	（223）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP108-1R3-K827（10.15-11.45GHz）	（224）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP107-1R0-M487（10.2-11.2GHz）	（225）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP108-1R2-K821（10.2-11.4GHz）	（226）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP115-2R6-K255（10.2-12.8GHz）	（227）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP106-0R6-K346（10.3-10.9GHz）	（228）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP112-1R8-K504（10.3-12.1GHz）	（229）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP115-2R3-K832（10.3-12.6GHz）	（230）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP129-5R2-K564（10.3-15.5GHz）	（231）	点此查看规格书

电话：(+86)156 0809 5669　　邮箱：sales@com-mw.com
传真：(+86)028 8408 5893　　地址：四川省成都市成华区航天路118号4-3单元

微信扫码联系

带通滤波器 STBP112-1R6-K355（10.4-12.0GHz） ..... （232） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP122-3R6-M369（10.4-14.0GHz） ..... （233） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP112-1R3-M672（10.5-11.8GHz） ..... （234） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP113-1R5-M613（10.5-12.0GHz） ..... （235） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP115-1R9-K591（10.5-12.4GHz） ..... （236） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP113-1R4-K659（10.6-12.0GHz） ..... （237） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP115-1R8-M650（10.6-12.4GHz） ..... （238） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP123-3R4-K537（10.6-14.0GHz） ..... （239） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP112-1R0-N500（10.7-11.7GHz） ..... （240） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP124-3R3-M432（10.7-14.0GHz） ..... （241） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP111-0R6-K347（10.8-11.4GHz） ..... （242） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP119-2R2-M576（10.8-13.0GHz） ..... （243） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP124-3R2-K506（10.8-14.0GHz） ..... （244） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP148-8R0-N420（10.8-18.8GHz） ..... （245） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP117-1R6-K356（10.9-12.5GHz） ..... （246） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP118-1R8-M135（10.9-12.7GHz） ..... （247） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP110-0R1-N161（11.0-11.1GHz） ..... （248） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP111-0R1-N207（11.0-11.1GHz） ..... （249） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP112-0R6-K814（11.0-11.4GHz） ..... （250） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP117-1R4-K257（11.0-12.4GHz） ..... （251） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP129-3R8-K865（11.0-14.8GHz） ..... （252） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP130-4R0-K888（11.0-15.0GHz） ..... （253） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP131-4R1-K862（11.0-15.1GHz） ..... （254） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP113-0R2-N162（11.2-11.4GHz） ..... （255） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP126-2R7-M492（11.2-13.9GHz） ..... （256） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP149-7R4-M332（11.2-18.6GHz） ..... （257） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP118-0R9-K348（11.3-12.2GHz） ..... （258） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP134-4R2-M710（11.3-15.5GHz） ..... （259） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP119-0R9-N501（11.45-12.35GHz） ..... （260） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP122-1R3-M673（11.5-12.8GHz） ..... （261） 点此查看规格书

电话：(+86)156 0809 5669 邮箱：sales@com-mw.com
传真：(+86)028 8408 5893 地址：四川省成都市成华区航天路118号4-3单元

微信扫码联系

带通滤波器 STBP122-1R4-K546（11.5-12.9GHz） ..... （262） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP126-2R2-N330（11.5-13.7GHz） ..... （263） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP137-4R3-M652（11.5-15.8GHz） ..... （264） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP117-0R1-N208（11.6-11.7GHz） ..... （265） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP125-1R8-N323（11.6-13.4GHz） ..... （266） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP127-2R3-M253（11.6-13.9GHz） ..... （267） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP135-3R8-M331（11.6-15.4GHz） ..... （268） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP150-6R6-M350（11.7-18.3GHz） ..... （269） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP134-3R2-K744（11.8-15.0GHz） ..... （270） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP142-4R8-M349（11.8-16.6GHz） ..... （271） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP120-0R2-N163（11.9-12.1GHz） ..... （272） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP121-0R4-M402（11.9-12.3GHz） ..... （273） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP120-0R0-M706（12GHz） ..... （274） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP123-0R6-M732（12.0-12.6GHz） ..... （275） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP128-1R5-K660（12.0-13.5GHz） ..... （276） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP135-3R0-M298（12.0-15.0GHz） ..... （277） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP141-4R2-M424（12.0-16.2GHz） ..... （278） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP148-5R6-M575（12.0-17.6GHz） ..... （279） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP152-6R4-M662（12.0-18.4GHz） ..... （280） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP153-6R6-N333（12.0-18.6GHz） ..... （281） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP121-0R1-N210（12.05-12.15GHz） ..... （282） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP125-0R5-N331（12.2-12.7GHz） ..... （283） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP127-1R1-M488（12.2-13.3GHz） ..... （284） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP128-1R2-K505（12.2-13.4GHz） ..... （285） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP170-9R6-K571（12.2-21.8GHz） ..... （286） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP136-2R5-M554（12.3-14.8GHz） ..... （287） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP131-1R4-M651（12.4-13.8GHz） ..... （288） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP125-0R0-M707（12.45GHz） ..... （289） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP130-1R0-K573（12.5-13.5GHz） ..... （290） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP132-1R4-M614（12.5-13.9GHz） ..... （291） 点此查看规格书

电话：(+86)156 0809 5669 邮箱：sales@com-mw.com
传真：(+86)028 8408 5893 地址：四川省成都市成华区航天路118号4-3单元

微信扫码联系

带通滤波器	STBP138-2R5-K596（12.5-15.0GHz）	……	（292）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP142-3R4-M504（12.5-15.9GHz）	……	（293）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP155-5R9-M512（12.5-18.4GHz）	……	（294）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP145-3R6-K720（12.7-16.3GHz）	……	（295）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP130-0R2-N164（12.9-13.1GHz）	……	（296）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP139-1R9-N327（12.9-14.8GHz）	……	（297）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP140-2R2-M440（12.9-15.1GHz）	……	（298）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP145-3R2-K533（12.9-16.1GHz）	……	（299）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP130-0R1-N211（12.95-13.05GHz）	……	（300）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP130-0R0-M708（13.0GHz）	……	（301）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP138-1R6-K530（13.0-14.6GHz）	……	（302）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP137-1R2-K507（13.1-14.3GHz）	……	（303）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP138-1R3-K258（13.1-14.4GHz）	……	（304）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP141-2R0-M558（13.1-15.1GHz）	……	（305）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP135-0R6-M684（13.2-13.8GHz）	……	（306）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP137-1R0-K828（13.2-14.2GHz）	……	（307）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP165-6R6-K721（13.2-19.8GHz）	……	（308）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP147-2R7-M493（13.3-16.0GHz）	……	（309）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP134-0R0-M709（13.4GHz）	……	（310）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP141-1R3-K833（13.4-14.7GHz）	……	（311）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP141-1R4-M674（13.4-14.8GHz）	……	（312）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP149-2R9-M370（13.4-16.3GHz）	……	（313）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP160-5R2-X351（13.4-18.6GHz）	……	（314）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP163-5R8-K822（13.4-19.2GHz）	……	（315）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP171-7R4-K598（13.4-20.8GHz）	……	（316）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP143-1R6-K661（13.5-15.1GHz）	……	（317）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP144-1R8-N324（13.5-15.3GHz）	……	（318）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP160-5R0-K787（13.5-18.5GHz）	……	（319）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP160-5R0-K871（13.5-18.5GHz）	……	（320）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP177-8R4-M479（13.5-21.9GHz）	……	（321）	点此查看规格书

电话：(+86)156 0809 5669　　邮箱：sales@com-mw.com
传真：(+86)028 8408 5893　　地址：四川省成都市成华区航天路118号4-3单元

微信扫码联系

带通滤波器	STBP142-1R2-K829（13.6-14.8GHz）	（322）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP160-4R7-M351（13.6-18.3GHz）	（323）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP157-3R9-M433（13.7-17.6GHz）	（324）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP189-104-M334（13.7-24.1GHz）	（325）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP139-0R2-K869（13.8-14.0GHz）	（326）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP139-0R2-N165（13.8-14.0GHz）	（327）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP141-0R6-K681（13.8-14.4GHz）	（328）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP145-1R3-M405（13.8-15.1GHz）	（329）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP148-2R0-M255（13.8-15.8GHz）	（330）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP150-2R4-M653（13.8-16.2GHz）	（331）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP156-3R6-N263（13.8-17.4GHz）	（332）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP168-6R0-N366（13.8-19.8GHz）	（333）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP139-0R0-K843（13.9GHz）	（334）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP140-0R2-K870（13.9-14.1GHz）	（335）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP140-0R1-N212（13.95-14.05GHz）	（336）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP140-0R0-M711（14GHz）	（337）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP147-1R3-N033（14.0-15.3GHz）	（338）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP167-5R4-M353（14.0-19.4GHz）	（339）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP150-1R7-M571（14.1-15.8GHz）	（340）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP162-4R2-M352（14.1-18.3GHz）	（341）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP147-1R0-M404（14.2-15.2GHz）	（342）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP157-3R0-M494（14.2-17.2GHz）	（343）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP161-3R7-M570（14.2-17.9GHz）	（344）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP165-4R3-M372（14.3-18.6GHz）	（345）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP149-1R0-N397（14.4-15.4GHz）	（346）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP176-6R3-K565（14.4-20.7GHz）	（347）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP145-0R0-M712（14.5GHz）	（348）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP152-1R4-M615（14.5-15.9GHz）	（349）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP162-3R3-K866（14.5-17.9GHz）	（350）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP164-3R5-K745（14.6-18.1GHz）	（351）	点此查看规格书

电话：(+86)156 0809 5669　　邮箱：sales@com-mw.com
传真：(+86)028 8408 5893　　地址：四川省成都市成华区航天路118号4-3单元

微信扫码联系

带通滤波器	STBP165-3R7-K890（14.6-18.3GHz）	（352）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP165-3R6-K863（14.7-18.3GHz）	（353）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP175-5R4-N252（14.8-20.2GHz）	（354）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP177-5R8-K562（14.8-20.6GHz）	（355）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP165-3R2-M318（14.9-18.1GHz）	（356）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP170-4R1-M434（14.9-19.0GHz）	（357）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP171-4R4-M333（14.9-19.3GHz）	（358）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP175-5R2-M585（14.9-20.1GHz）	（359）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP150-0R0-M713（15GHz）	（360）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP158-1R6-K662（15.0-16.6GHz）	（361）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP160-2R0-M441（15.0-17.0GHz）	（362）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP167-3R4-M503（15.0-18.4GHz）	（363）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP168-3R6-X503（15.0-18.6GHz）	（364）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP174-5R0-M544（15.0-19.8GHz）	（365）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP151-0R1-N387（15.05-15.15GHz）	（366）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP161-1R7-M572（15.2-16.9GHz）	（367）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP165-2R6-M454（15.2-17.8GHz）	（368）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP177-5R0-M541（15.2-20.2GHz）	（369）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP158-1R0-K259（15.3-16.3GHz）	（370）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP179-5R2-K872（15.3-20.5GHz）	（371）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP165-2R2-M603（15.4-17.6GHz）	（372）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP170-3R2-M371（15.4-18.6GHz）	（373）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP172-3R6-K782（15.4-19.0GHz）	（374）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP182-5R6-N335（15.4-21.0GHz）	（375）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP162-1R4-M508（15.5-16.9GHz）	（376）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP166-2R1-M552（15.5-17.6GHz）	（377）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP158-0R4-N332（15.6-16.0GHz）	（378）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP163-1R1-N334（15.7-16.8GHz）	（379）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP169-2R2-M462（15.8-18.0GHz）	（380）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP187-5R8-M355（15.8-21.6GHz）	（381）	点此查看规格书

电话：(+86)156 0809 5669　　邮箱：sales@com-mw.com
传真：(+86)028 8408 5893　　地址：四川省成都市成华区航天路118号4-3单元

微信扫码联系

带通滤波器	STBP188-5R8-K312（15.9-21.7GHz）	（382）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP160-0R0-M714（16GHz）	（383）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP171-2R1-M654（16.0-18.1GHz）	（384）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP183-4R6-K722（16.0-20.6GHz）	（385）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP193-6R6-K874（16.0-22.6GHz）	（386）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP191-6R2-K442（16.0-22.2GHz）	（387）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP195-7R0-K646（16.0-23.0GHz）	（388）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP161-0R1-N388（16.05-16.15GHz）	（389）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP169-1R6-N325（16.1-17.7GHz）	（390）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP170-1R7-M579（16.1-17.8GHz）	（391）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP168-1R2-M256（16.2-17.4GHz）	（392）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP193-6R2-N251（16.2-22.4GHz）	（393）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP168-1R0-M274（16.3-17.3GHz）	（394）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP177-2R8-M495（16.3-19.1GHz）	（395）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP205-8R4-N421（16.3-24.7GHz）	（396）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP172-1R6-K663（16.4-18.0GHz）	（397）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP201-7R4-K667（16.4-23.8GHz）	（398）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP174-1R3-N241（16.7-18.0GHz）	（399）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP205-7R8-N565（16.7-24.3GHz）	（400）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP218-100-M383（16.8-26.8GHz）	（401）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP202-6R6-K823（16.9-23.5GHz）	（402）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP178-1R6-K804（17.0-18.6GHz）	（403）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP183-2R6-M354（17.0-19.6GHz）	（404）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP185-3R0-M375（17.0-20.0GHz）	（405）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP185-3R0-K873（17.0-20.0GHz）	（406）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP196-5R2-M590（17.0-22.2GHz）	（407）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP202-6R4-M409（17.0-23.4GHz）	（408）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP171-0R1-N389（17.05-17.15GHz）	（409）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP194-4R6-M391（17.2-21.8GHz）	（410）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP195-4R6-K875（17.2-21.8GHz）	（411）	点此查看规格书

电话：(+86)156 0809 5669　　邮箱：sales@com-mw.com
传真：(+86)028 8408 5893　　地址：四川省成都市成华区航天路118号4-3单元

微信扫码联系

带通滤波器 STBP199-5R4-M417（17.2-22.6GHz）……（412） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP201-5R8-K406（17.2-23.0GHz）……（413） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP219-9R4-M421（17.2-26.6GHz）……（414） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP181-1R5-M288（17.3-18.8GHz）……（415） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP214-8R2-M359（17.3-25.5GHz）……（416） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP220-9R4-M336（17.3-26.7GHz）……（417） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP195-4R2-M484（17.4-21.6GHz）……（418） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP208-6R8-M357（17.4-24.2GHz）……（419） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP210-7R1-M335（17.4-24.5GHz）……（420） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP220-9R2-K369（17.4-26.6GHz）……（421） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP199-4R8-N250（17.5-22.3GHz）……（422） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP230-9R0-K600（17.5-27.5GHz）……（423） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP202-5R2-K797（17.6-22.8GHz）……（424） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP220-8R8-M513（17.6-26.4GHz）……（425） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP224-9R3-K942（17.7-27.0GHz）……（426） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP180-0R3-M438（17.8-18.1GHz）……（427） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP186-1R5-N235（17.8-19.3GHz）……（428） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP188-2R0-N326（17.8-19.8GHz）……（429） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP212-6R8-N288（17.8-24.6GHz）……（430） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP218-8R0-K877（17.8-25.8GHz）……（431） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP221-8R6-K536（17.8-26.4GHz）……（432） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP179-0R0-K788（17.9GHz）……（433） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP180-0R2-M522（17.9-18.1GHz）……（434） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP189-1R9-K638（17.9-19.8GHz）……（435） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP196-3R3-M386（17.9-21.2GHz）……（436） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP200-4R2-M514（17.9-22.1GHz）……（437） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP187-1R4-K738（18.0-19.4GHz）……（438） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP189-1R8-M437（18.0-19.8GHz）……（439） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP191-2R2-M276（18.0-20.2GHz）……（440） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP192-2R4-M551（18.0-20.4GHz）……（441） 点此查看规格书

电话：(+86)156 0809 5669 邮箱：sales@com-mw.com
传真：(+86)028 8408 5893 地址：四川省成都市成华区航天路118号4-3单元

微信扫码联系

带通滤波器	STBP199-3R7-M448（18.0-21.7GHz）	……	（442）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP205-4R9-M569（18.0-22.9GHz）	……	（443）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP223-8R6-X358（18.0-26.6GHz）	……	（444）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP233-106-N539（18.0-28.6GHz）	……	（445）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP181-0R1-N390（18.05-18.15GHz）	……	（446）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP199-3R4-K746（18.2-21.6GHz）	……	（447）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP212-6R0-K760（18.2-24.2GHz）	……	（448）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP213-6R2-K711（18.2-24.4GHz）	……	（449）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP198-2R9-M496（18.3-21.2GHz）	……	（450）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP220-7R2-K599（18.4-25.6GHz）	……	（451）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP186-0R2-M507（18.5-18.7GHz）	……	（452）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP225-8R0-M358（18.5-26.5GHz）	……	（453）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP206-4R0-M356（18.6-22.6GHz）	……	（454）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP206-3R6-M718（18.8-22.4GHz）	……	（455）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP201-2R5-K547（18.9-21.4GHz）	……	（456）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP191-0R1-N391（19.0-19.1GHz）	……	（457）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP199-1R7-K805（19.0-20.7GHz）	……	（458）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP205-3R0-M457（19.0-22.0GHz）	……	（459）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP196-0R8-N200（19.2-20.0GHz）	……	（460）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP199-1R4-K798（19.2-20.6GHz）	……	（461）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP204-2R4-K538（19.2-21.6GHz）	……	（462）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP247-110-M408（19.2-30.2GHz）	……	（463）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP193-0R0-M715（19.3GHz）	……	（464）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP221-5R4-K566（19.4-24.8GHz）	……	（465）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP200-1R0-K556（19.5-20.5GHz）	……	（466）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP204-1R5-M563（19.6-21.1GHz）	……	（467）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP218-4R4-K824（19.6-24.0GHz）	……	（468）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP200-0R3-M439（19.8-20.1GHz）	……	（469）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP201-0R5-N368（19.8-20.3GHz）	……	（470）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP223-5R0-M591（19.8-24.8GHz）	……	（471）	点此查看规格书

电话：(+86)156 0809 5669　　邮箱：sales@com-mw.com
传真：(+86)028 8408 5893　　地址：四川省成都市成华区航天路118号4-3单元

微信扫码联系

带通滤波器 STBP227-5R8-K610（19.8-25.6GHz） ..... （472） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP247-9R8-M361（19.8-29.6GHz） ..... （473） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP206-1R2-K741（20.0-21.2GHz） ..... （474） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP209-1R4-M604（20.0-21.6GHz） ..... （475） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP220-4R0-M279（20.0-24.0GHz） ..... （476） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP229-5R8-M586（20.0-25.8GHz） ..... （477） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP230-6R0-M629（20.0-26.0GHz） ..... （478） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP207-1R2-M489（20.1-21.3GHz） ..... （479） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP218-3R4-N024（20.1-23.5GHz） ..... （480） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP208-1R6-N254（20.2-21.6GHz） ..... （481） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP210-1R5-X489（20.2-21.7GHz） ..... （482） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP210-1R6-K876（20.2-21.8GHz） ..... （483） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP211-1R8-M435（20.2-22.0GHz） ..... （484） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP217-3R0-M456（20.2-23.2GHz） ..... （485） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP229-5R4-N281（20.2-25.6GHz） ..... （486） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP248-8R8-M413（20.4-29.2GHz） ..... （487） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP207-0R1-N475（20.6-20.7GHz） ..... （488） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP210-0R8-M523（20.6-21.4GHz） ..... （489） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP231-4R6-M392（20.7-25.5GHz） ..... （490） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP218-2R0-K629（20.8-22.8GHz） ..... （491） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP235-5R4-M418（20.8-26.2GHz） ..... （492） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP245-7R4-N217（20.8-28.2GHz） ..... （493） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP213-0R6-M521（21.0-21.6GHz） ..... （494） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP218-1R6-K806（21.0-22.6GHz） ..... （495） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP226-3R2-N266（21.0-24.2GHz） ..... （496） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP239-5R8-K800（21.0-26.8GHz） ..... （497） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP245-7R0-K825（21.0-28.0GHz） ..... （498） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP215-0R8-M360（21.1-21.9GHz） ..... （499） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP218-1R2-K432（21.2-22.4GHz） ..... （500） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP220-1R6-N249（21.2-22.8GHz） ..... （501） 点此查看规格书

电话：(+86)156 0809 5669 邮箱：sales@com-mw.com
传真：(+86)028 8408 5893 地址：四川省成都市成华区航天路118号4-3单元

微信扫码联系

带通滤波器 STBP226-2R8-K747（21.2-24.0GHz） ..... （502） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP219-1R2-M675（21.3-22.5GHz） ..... （503） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP221-1R4-N554（21.4-22.8GHz） ..... （504） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP227-2R6-N299（21.4-24.0GHz） ..... （505） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP233-3R8-N264（21.4-25.2GHz） ..... （506） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP255-8R2-M449（21.4-29.6GHz） ..... （507） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP218-0R6-N253（21.5-22.1GHz） ..... （508） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP220-0R9-M658（21.5-22.4GHz） ..... （509） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP245-6R0-K407（21.5-27.5GHz） ..... （510） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP226-2R0-M206（21.6-23.6GHz） ..... （511） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP237-4R2-M311（21.6-25.8GHz） ..... （512） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP275-115-N482（21.7-33.2GHz） ..... （513） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP221-0R6-K647（21.8-22.4GHz） ..... （514） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP224-1R2-M470（21.8-23.0GHz） ..... （515） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP241-4R6-K548（21.8-26.4GHz） ..... （516） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP243-5R0-K260（21.8-26.8GHz） ..... （517） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP250-6R4-M534（21.8-28.2GHz） ..... （518） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP223-0R8-N201（21.9-22.7GHz） ..... （519） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP227-1R5-K879（21.9-23.4GHz） ..... （520） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP235-3R0-M387（22.0-25.0GHz） ..... （521） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP236-3R2-K630（22.0-25.2GHz） ..... （522） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP264-8R8-N236（22.0-30.8GHz） ..... （523） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP225-0R7-M469（22.1-22.8GHz） ..... （524） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP225-0R6-M473（22.2-22.8GHz） ..... （525） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP226-0R8-K878（22.2-23.0GHz） ..... （526） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP228-1R2-M460（22.2-23.4GHz） ..... （527） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP229-1R4-M460（22.2-23.6GHz） ..... （528） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP237-3R0-N300（22.2-25.2GHz） ..... （529） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP242-4R0-M568（22.2-26.2GHz） ..... （530） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP248-5R2-M592（22.2-27.4GHz） ..... （531） 点此查看规格书

电话：(+86)156 0809 5669 邮箱：sales@com-mw.com
传真：(+86)028 8408 5893 地址：四川省成都市成华区航天路118号4-3单元

微信扫码联系

带通滤波器 STBP261-7R8-N422（22.2-30.0GHz） ..... （532） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP224-0R2-N427（22.3-22.5GHz） ..... （533） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP224-0R2-N486（22.3-22.5GHz） ..... （534） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP225-0R1-N457（22.4-22.5GHz） ..... （535） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP227-0R6-M459（22.4-23.0GHz） ..... （536） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP226-0R2-N551（22.5-22.7GHz） ..... （537） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP229-0R8-K648（22.5-23.3GHz） ..... （538） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP323-195-N503（22.5-42.0GHz） ..... （539） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP248-4R2-N534（22.7-26.9GHz） ..... （540） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP250-4R4-K498（22.8-27.2GHz） ..... （541） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP259-6R2-N310（22.8-29.0GHz） ..... （542） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP261-6R3-N566（22.9-29.2GHz） ..... （543） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP262-6R4-K603（23.0-29.4GHz） ..... （544） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP300-140-N237（23.0-37.0GHz） ..... （545） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP234-0R2-N458（23.1-23.3GHz） ..... （546） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP233-0R3-N428（23.1-23.4GHz） ..... （547） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP248-3R4-K826（23.1-26.5GHz） ..... （548） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP234-0R3-N487（23.2-23.5GHz） ..... （549） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP247-3R0-N301（23.2-26.2GHz） ..... （550） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP275-8R6-M362（23.2-31.8GHz） ..... （551） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP268-6R8-K712（23.4-30.2GHz） ..... （552） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP279-9R0-M685（23.4-32.4GHz） ..... （553） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP280-9R2-M337（23.4-32.6GHz） ..... （554） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP280-9R2-M656（23.4-32.6GHz） ..... （555） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP240-1R0-M663（23.5-24.5GHz） ..... （556） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP265-6R0-N291（23.5-29.5GHz） ..... （557） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP287-104-N224（23.5-33.9GHz） ..... （558） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP258-4R2-N219（23.7-27.9GHz） ..... （559） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP252-2R8-K748（23.8-26.6GHz） ..... （560） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP264-5R2-N319（23.8-29.0GHz） ..... （561） 点此查看规格书

电话：(+86)156 0809 5669 邮箱：sales@com-mw.com
传真：(+86)028 8408 5893 地址：四川省成都市成华区航天路118号4-3单元

微信扫码联系

带通滤波器 STBP265-5R4-N320（23.8-29.2GHz） ..... （562） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP273-7R0-K335（23.8-30.8GHz） ..... （563） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP244-1R0-M312（23.9-24.9GHz） ..... （564） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP254-3R0-K731（23.9-26.9GHz） ..... （565） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP260-4R2-M280（23.9-28.1GHz） ..... （566） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP263-4R6-M320（24.0-28.6GHz） ..... （567） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP315-150-N362（24.0-39.0GHz） ..... （568） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP250-1R7-M294（24.1-25.8GHz） ..... （569） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP251-2R0-K665（24.1-26.1GHz） ..... （570） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP257-3R2-N302（24.1-27.3GHz） ..... （571） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP290-9R6-K632（24.2-33.8GHz） ..... （572） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP267-4R8-M393（24.3-29.1GHz） ..... （573） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP299-107-K539（24.5-35.2GHz） ..... （574） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP286-8R0-K650（24.6-32.6GHz） ..... （575） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP288-8R4-M363（24.6-33.0GHz） ..... （576） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP259-2R2-K631（24.8-27.0GHz） ..... （577） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP270-4R4-N255（24.8-29.2GHz） ..... （578） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP276-5R2-M419（25.0-30.2GHz） ..... （579） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP278-5R6-K801（25.0-30.6GHz） ..... （580） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP255-0R8-N202（25.1-25.9GHz） ..... （581） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP294-8R6-M384（25.1-33.7GHz） ..... （582） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP256-0R8-M313（25.2-26.0GHz） ..... （583） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP276-4R8-M593（25.2-30.0GHz） ..... （584） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP290-7R6-M364（25.2-32.8GHz） ..... （585） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP258-0R8-K649（25.4-26.2GHz） ..... （586） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP265-2R2-M244（25.4-27.6GHz） ..... （587） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP287-6R6-M627（25.4-32.0GHz） ..... （588） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP259-0R7-M226（25.5-26.2GHz） ..... （589） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP331-150-K847（25.6-40.6GHz） ..... （590） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP267-1R9-K848（25.7-27.6GHz） ..... （591） 点此查看规格书

电话：(+86)156 0809 5669 邮箱：sales@com-mw.com
传真：(+86)028 8408 5893 地址：四川省成都市成华区航天路118号4-3单元

微信扫码联系

带通滤波器 STBP276-3R6-N444（25.8-29.4GHz） ..... （592） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP276-3R6-K835（25.8-29.4GHz） ..... （593） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP262-0R6-N294（25.9-26.5GHz） ..... （594） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP263-0R8-K613（25.9-26.7GHz） ..... （595） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP267-1R6-K664（25.9-27.5GHz） ..... （596） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP269-1R8-N511（26.0-27.8GHz） ..... （597） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP281-4R2-N411（26.0-30.2GHz） ..... （598） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP298-7R6-K604（26.0-33.6GHz） ..... （599） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP323-126-M607（26.0-38.6GHz） ..... （600） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP267-0R9-M314（26.2-27.1GHz） ..... （601） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP312-100-M410（26.2-36.2GHz） ..... （602） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP268-1R0-K551（26.3-27.3GHz） ..... （603） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP270-1R4-K737（26.3-27.7GHz） ..... （604） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP290-5R2-K408（26.4-31.6GHz） ..... （605） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP320-110-M535（26.5-27.5GHz） ..... （606） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP286-4R0-M605（26.6-30.6GHz） ..... （607） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP290-4R6-M542（26.7-31.3GHz） ..... （608） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP331-126-M339（26.8-39.4GHz） ..... （609） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP279-2R0-N512（26.9-28.9GHz） ..... （610） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP310-8R0-M416（27.0-35.0GHz） ..... （611） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP334-132-K894（27.0-39.4GHz） ..... （612） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP286-2R8-K815（27.2-30.0GHz） ..... （613） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP290-3R5-N406（27.2-30.7GHz） ..... （614） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP290-3R6-N535（27.2-30.8GHz） ..... （615） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP284-2R0-K733（27.4-29.4GHz） ..... （616） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP286-2R4-N382（27.4-29.8GHz） ..... （617） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP286-2R4-K818（27.4-29.8GHz） ..... （618） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP338-128-M365（27.4-40.2GHz） ..... （619） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP278-0R6-M315（27.5-28.1GHz） ..... （620） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP282-1R4-K754（27.5-28.9GHz） ..... （621） 点此查看规格书

电话：(+86)156 0809 5669 邮箱：sales@com-mw.com
传真：(+86)028 8408 5893 地址：四川省成都市成华区航天路118号4-3单元

微信扫码联系

带通滤波器	STBP283-1R6-K666（27.5-29.1GHz）	……	（622）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP297-4R4-K451（27.5-31.9GHz）	……	（623）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP300-5R0-N567（27.5-32.5GHz）	……	（624）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP298-4R4-N220（27.6-32.0GHz）	……	（625）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP308-6R4-N467（27.6-34.0GHz）	……	（626）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP282-1R0-K732（27.7-28.7GHz）	……	（627）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP288-2R0-N513（27.8-29.8GHz）	……	（628）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP301-4R6-K495（27.8-32.4GHz）	……	（629）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP310-6R4-M278（27.8-34.2GHz）	……	（630）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP315-7R4-M426（27.8-35.2GHz）	……	（631）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP317-7R6-N465（27.9-35.5GHz）	……	（632）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP303-4R6-M321（28.0-32.6GHz）	……	（633）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP310-6R0-N423（28.0-34.0GHz）	……	（634）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP289-1R4-M287（28.2-29.6GHz）	……	（635）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP302-4R0-N445（28.2-32.2GHz）	……	（636）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP302-3R7-K836（28.3-32.0GHz）	……	（637）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP307-4R7-M394（28.3-33.0GHz）	……	（638）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP291-1R4-K755（28.4-29.8GHz）	……	（639）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP347-126-N225（28.4-41.0GHz）	……	（640）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP347-122-K684（28.6-40.8GHz）	……	（641）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP300-2R6-M388（28.7-31.3GHz）	……	（642）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP297-1R8-M716（28.8-30.6GHz）	……	（643）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP307-3R6-K452（28.9-32.5GHz）	……	（644）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP295-1R0-K734（29.0-30.0GHz）	……	（645）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP299-1R8-N514（29.0-30.8GHz）	……	（646）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP300-2R0-K531（29.0-31.0GHz）	……	（647）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP316-5R2-M420（29.0-34.2GHz）	……	（648）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP317-5R4-K802（29.0-34.4GHz）	……	（649）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP319-5R8-N292（29.0-34.8GHz）	……	（650）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP322-6R4-K682（29.0-35.4GHz）	……	（651）	点此查看规格书

电话：(+86)156 0809 5669　　邮箱：sales@com-mw.com
传真：(+86)028 8408 5893　　地址：四川省成都市成华区航天路118号4-3单元

微信扫码联系

带通滤波器	STBP330-7R6-K517（29.2-36.8GHz）	（652）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP300-1R4-K756（29.3-30.7GHz）	（653）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP317-4R6-K971（29.4-34.0GHz）	（654）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP340-9R2-K334（29.4-38.6GHz）	（655）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP299-0R6-K651（29.6-30.2GHz）	（656）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP306-2R0-M717（29.6-31.6GHz）	（657）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP331-7R0-K605（29.6-36.6GHz）	（658）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP352-112-N424（29.6-40.8GHz）	（659）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP317-3R8-N303（29.8-33.6GHz）	（660）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP323-5R0-M450（29.8-34.8GHz）	（661）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP330-6R4-N238（29.8-36.2GHz）	（662）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP304-0R8-M573（30.0-30.8GHz）	（663）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP307-1R3-M286（30.0-31.3GHz）	（664）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP309-1R8-N515（30.0-31.8GHz）	（665）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP342-4R4-N412（30.0-34.4GHz）	（666）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP324-4R8-X420（30.0-34.8GHz）	（667）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP325-5R0-M587（30.0-35.0GHz）	（668）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP345-9R0-M340（30.0-39.0GHz）	（669）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP307-1R2-K730（30.1-31.3GHz）	（670）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP320-3R6-M606（30.2-33.8GHz）	（671）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP352-100-M385（30.2-40.2GHz）	（672）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP324-3R4-K837（30.7-34.1GHz）	（673）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP328-4R0-N536（30.8-34.8GHz）	（674）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP334-5R2-K409（30.8-36.0GHz）	（675）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP327-3R6-N304（30.9-34.5GHz）	（676）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP341-6R4-K655（30.9-37.3GHz）	（677）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP342-6R0-M381（31.2-37.2GHz）	（678）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP343-6R5-N568（31.3-37.1GHz）	（679）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP337-4R6-N221（31.4-36.0GHz）	（680）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP335-4R0-N446（31.5-35.5GHz）	（681）	点此查看规格书

电话：(+86)156 0809 5669　　邮箱：sales@com-mw.com
传真：(+86)028 8408 5893　　地址：四川省成都市成华区航天路118号4-3单元

微信扫码联系

带通滤波器	STBP353-7R5-M376（31.5-39.0GHz）	（682）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP321-1R0-N350（31.6-32.6GHz）	（683）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP374-116-M368（31.6-43.2GHz）	（684）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP381-130-K652（31.6-44.6GHz）	（685）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP325-1R6-N351（31.7-33.3GHz）	（686）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP360-8R6-M628（31.7-40.3GHz）	（687）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP359-8R2-M341（31.8-40.0GHz）	（688）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP343-4R8-M322（31.9-36.7GHz）	（689）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP330-1R9-M389（32.0-33.9GHz）	（690）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP341-4R2-M422（32.0-36.2GHz）	（691）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP354-6R8-K683（32.0-38.8GHz）	（692）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP361-8R2-M366（32.0-40.2GHz）	（693）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP361-8R2-M659（32.0-40.2GHz）	（694）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP363-8R6-M367（32.0-40.6GHz）	（695）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP400-160-M625（32.0-48.0GHz）	（696）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP349-5R4-M642（32.2-37.6GHz）	（697）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP330-0R8-N352（32.6-33.4GHz）	（698）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP349-4R4-M395（32.7-37.1GHz）	（699）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP353-5R0-K456（32.8-37.8GHz）	（700）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP338-1R6-K385（33.0-34.6GHz）	（701）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP344-2R8-K411（33.0-35.8GHz）	（702）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP348-3R6-M588（33.0-36.6GHz）	（703）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP353-4R6-K428（33.0-37.6GHz）	（704）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP356-5R2-K455（33.0-38.2GHz）	（705）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP360-6R0-N468（33.0-39.0GHz）	（706）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP360-6R0-K496（33.0-39.0GHz）	（707）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP360-6R0-M533（33.0-39.0GHz）	（708）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP372-8R4-M411（33.0-41.4GHz）	（709）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP355-4R6-M596（33.2-37.8GHz）	（710）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP359-5R3-N282（33.2-38.5GHz）	（711）	点此查看规格书

电话：(+86)156 0809 5669　　邮箱：sales@com-mw.com
传真：(+86)028 8408 5893　　地址：四川省成都市成华区航天路118号4-3单元

微信扫码联系

带通滤波器 STBP363-6R2-K654（33.2-39.4GHz） ..... （712） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP365-6R6-N425（33.2-39.8GHz） ..... （713） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP343-1R6-M574（33.5-35.1GHz） ..... （714） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP368-6R4-N466（33.6-40.0GHz） ..... （715） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP370-6R6-M281（33.7-40.3GHz） ..... （716） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP346-1R6-M609（33.8-35.4GHz） ..... （717） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP349-2R2-K386（33.8-36.0GHz） ..... （718） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP384-9R2-K606（33.8-43.0GHz） ..... （719） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP387-9R8-N226（33.8-43.6GHz） ..... （720） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP361-4R2-M423（34.0-38.2GHz） ..... （721） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP350-1R6-K379（34.2-35.8GHz） ..... （722） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP359-3R4-K388（34.2-37.6GHz） ..... （723） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP362-4R0-N413（34.2-38.2GHz） ..... （724） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP363-4R0-N447（34.3-38.3GHz） ..... （725） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP375-5R8-N293（34.6-40.4GHz） ..... （726） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP386-7R8-K518（34.7-42.5GHz） ..... （727） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP358-2R0-K387（34.8-36.8GHz） ..... （728） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP363-3R0-K412（34.8-37.8GHz） ..... （729） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP374-5R2-K410（34.8-40.0GHz） ..... （730） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP358-1R8-K585（34.9-36.7GHz） ..... （731） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP360-2R0-K586（35.0-37.0GHz） ..... （732） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP372-4R3-M589（35.0-39.3GHz） ..... （733） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP383-6R6-K685（35.0-41.6GHz） ..... （734） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP382-6R0-M382（35.2-41.2GHz） ..... （735） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP356-0R5-N488（35.3-35.8GHz） ..... （736） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP369-3R2-N256（35.3-38.5GHz） ..... （737） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP370-3R0-K453（35.5-38.5GHz） ..... （738） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP358-0R4-N510（35.6-36.0GHz） ..... （739） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP367-2R2-N400（35.6-37.8GHz） ..... （740） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP374-3R6-N222（35.6-39.2GHz） ..... （741） 点此查看规格书

电话：(+86)156 0809 5669 邮箱：sales@com-mw.com
传真：(+86)028 8408 5893 地址：四川省成都市成华区航天路118号4-3单元

微信扫码联系

带通滤波器 STBP382-5R2-K653（35.6-40.8GHz） ..... （742） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP367-2R0-K389（35.7-37.7GHz） ..... （743） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP378-4R0-N537（35.8-39.8GHz） ..... （744） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP380-4R4-M396（35.8-40.2GHz） ..... （745） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP392-6R8-K173（35.8-42.6GHz） ..... （746） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP393-7R0-K535（35.8-42.8GHz） ..... （747） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP382-4R3-M597（36.0-40.3GHz） ..... （748） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP376-3R0-K454（36.1-39.1GHz） ..... （749） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP384-4R6-M323（36.1-40.7GHz） ..... （750） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP377-2R2-N401（36.6-38.8GHz） ..... （751） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP383-3R0-M611（36.8-39.8GHz） ..... （752） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP415-9R4-M536（36.8-46.2GHz） ..... （753） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP409-7R8-M342（37.0-44.8GHz） ..... （754） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP390-3R4-N356（37.3-40.7GHz） ..... （755） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP402-5R6-N448（37.4-43.0GHz） ..... （756） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP388-2R5-N402（37.5-40.0GHz） ..... （757） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP394-3R8-N414（37.5-41.3GHz） ..... （758） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP391-2R2-K816（38.0-40.2GHz） ..... （759） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP391-2R0-M612（38.1-40.1GHz） ..... （760） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP447-126-M345（38.4-51.0GHz） ..... （761） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP418-6R4-N426（38.6-45.0GHz） ..... （762） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP439-106-N407（38.6-49.2GHz） ..... （763） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP410-4R6-K838（38.7-43.3GHz） ..... （764） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP396-1R6-N357（38.8-40.4GHz） ..... （765） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP398-2R0-K490（38.8-40.8GHz） ..... （766） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP424-7R2-M412（38.8-46.0GHz） ..... （767） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP445-110-M343（39.0-50.0GHz） ..... （768） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP445-106-M344（39.2-49.8GHz） ..... （769） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP451-112-N269（39.5-50.7GHz） ..... （770） 点此查看规格书
带通滤波器 STBP400-0R8-N295（39.6-40.4GHz） ..... （771） 点此查看规格书

电话：(+86)156 0809 5669 邮箱：sales@com-mw.com
传真：(+86)028 8408 5893 地址：四川省成都市成华区航天路118号4-3单元

微信扫码联系

带通滤波器	STBP401-1R0-K614（39.6-40.6GHz）	……	（772）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP446-100-M346（39.6-49.6GHz）	……	（773）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP410-2R0-K492（40.0-42.0GHz）	……	（774）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP419-3R8-N223（40.0-43.8GHz）	……	（775）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP421-4R2-M324（40.0-44.2GHz）	……	（776）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP452-8R8-M626（40.8-49.6GHz）	……	（777）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP463-110-K520（40.8-51.8GHz）	……	（778）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP429-3R8-N415（41.0-44.8GHz）	……	（779）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP422-2R0-K817（41.2-43.2GHz）	……	（780）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP444-6R4-K519（41.2-47.6GHz）	……	（781）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP439-4R5-N449（41.6-46.1GHz）	……	（782）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP472-6R0-N416（44.2-50.2GHz）	……	（783）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP463-7R8-N460（42.4-50.2GHz）	……	（784）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP446-2R0-M564（43.6-45.6GHz）	……	（785）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP475-7R4-M347（43.8-51.2GHz）	……	（786）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP460-4R2-M325（43.9-48.1GHz）	……	（787）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP483-7R0-K522（44.8-51.8GHz）	……	（788）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP458-1R6-K491（45.0-46.6GHz）	……	（789）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP478-4R5-N450（45.4-50.0GHz）	……	（790）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP488-6R5-M543（45.5-52.0GHz）	……	（791）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP497-6R6-K521（46.4-53.0GHz）	……	（792）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP480-2R0-N441（47.0-49.0GHz）	……	（793）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP508-4R8-N289（48.4-53.2GHz）	……	（794）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP542-9R0-N408（49.7-58.7GHz）	……	（795）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP509-1R4-K489（50.2-51.6GHz）	……	（796）	点此查看规格书
带通滤波器	STBP601-4R6-N170（57.8-62.4GHz）	……	（797）	点此查看规格书
高通滤波器	STHP6R0-M058（6.0-14.5GHz）	……	（798）	点此查看规格书
高通滤波器	STHP6R0-N469（6.0-18.0GHz）	……	（799）	点此查看规格书
高通滤波器	STHP6R2-M640（6.2-13.0GHz）	……	（800）	点此查看规格书
高通滤波器	STHP6R5-K267（6.5-18.5GHz）	……	（801）	点此查看规格书

电话：(+86)156 0809 5669　　邮箱：sales@com-mw.com
传真：(+86)028 8408 5893　　地址：四川省成都市成华区航天路118号4-3单元

微信扫码联系

高通滤波器 STHP7R0-M059（7.0-17.5GHz） ..... （802） 点此查看规格书
高通滤波器 STHP7R0-N522（7.0-20.5GHz） ..... （803） 点此查看规格书
高通滤波器 STHP8R0-M060（8.0-19.0GHz） ..... （804） 点此查看规格书
高通滤波器 STHP8R0-N523（8.0-22.5GHz） ..... （805） 点此查看规格书
高通滤波器 STHP9R2-M061（9.2-21.0GHz） ..... （806） 点此查看规格书
高通滤波器 STHP9R8-M062（9.8-23.0GHz） ..... （807） 点此查看规格书
高通滤波器 STHP110-M583（11.0-23.0GHz） ..... （808） 点此查看规格书
高通滤波器 STHP110-M063（11.0-27.0GHz） ..... （809） 点此查看规格书
高通滤波器 STHP118-M064（11.8-28.0GHz） ..... （810） 点此查看规格书
高通滤波器 STHP128-M065（12.8-29.0GHz） ..... （811） 点此查看规格书
高通滤波器 STHP138-M066（13.8-32.0GHz） ..... （812） 点此查看规格书
高通滤波器 STHP148-M067（14.8-35.0GHz） ..... （813） 点此查看规格书
高通滤波器 STHP158-M068（15.8-38.0GHz） ..... （814） 点此查看规格书
高通滤波器 STHP160-N318（16.0-50.0GHz） ..... （815） 点此查看规格书
高通滤波器 STHP162-M069（16.2-39.0GHz） ..... （816） 点此查看规格书
高通滤波器 STHP168-M070（16.8-40.0GHz） ..... （817） 点此查看规格书
高通滤波器 STHP180-K908（18.0-45.0GHz） ..... （818） 点此查看规格书
高通滤波器 STHP190-N317（19.0-46.0GHz） ..... （819） 点此查看规格书
低通滤波器 STLP3R0-N065（DC-3.0GHz） ..... （820） 点此查看规格书
低通滤波器 STLP3R3-N067（DC-3.3GHz） ..... （821） 点此查看规格书
低通滤波器 STLP3R7-M728（DC-3.7GHz） ..... （822） 点此查看规格书
低通滤波器 STLP3R7-N068（DC-3.7GHz） ..... （823） 点此查看规格书
低通滤波器 STLP3R8-K753（DC-3.8GHz） ..... （824） 点此查看规格书
低通滤波器 STLP3R8-N069（DC-3.8GHz） ..... （825） 点此查看规格书
低通滤波器 STLP4R2-M472（DC-4.2GHz） ..... （826） 点此查看规格书
低通滤波器 STLP4R3-N070（DC-4.3GHz） ..... （827） 点此查看规格书
低通滤波器 STLP4R8-M020（DC-4.8GHz） ..... （828） 点此查看规格书
低通滤波器 STLP4R8-N071（DC-4.8GHz） ..... （829） 点此查看规格书
低通滤波器 STLP5R5-M021（DC-5.5GHz） ..... （830） 点此查看规格书
低通滤波器 STLP5R8-M482（DC-5.8GHz） ..... （831） 点此查看规格书

电话：(+86)156 0809 5669 邮箱：sales@com-mw.com
传真：(+86)028 8408 5893 地址：四川省成都市成华区航天路118号4-3单元

微信扫码联系

低通滤波器 STLP6R0-K978（DC-6.0GHz） ..... （832） 点此查看规格书
低通滤波器 STLP6R1-N072（DC-6.1GHz） ..... （833） 点此查看规格书
低通滤波器 STLP6R7-N073（DC-6.7GHz） ..... （834） 点此查看规格书
低通滤波器 STLP6R8-M022（DC-6.8GHz） ..... （835） 点此查看规格书
低通滤波器 STLP7R5-M023（DC-7.5GHz） ..... （836） 点此查看规格书
低通滤波器 STLP7R5-M622（DC-7.5GHz） ..... （837） 点此查看规格书
低通滤波器 STLP7R5-N074（DC-7.5GHz） ..... （838） 点此查看规格书
低通滤波器 STLP8R0-N075（DC-8.0GHz） ..... （839） 点此查看规格书
低通滤波器 STLP8R2-M024（DC-8.2GHz） ..... （840） 点此查看规格书
低通滤波器 STLP8R7-N076（DC-8.7GHz） ..... （841） 点此查看规格书
低通滤波器 STLP9R4-M025（DC-9.4GHz） ..... （842） 点此查看规格书
低通滤波器 STLP9R8-N077（DC-9.8GHz） ..... （843） 点此查看规格书
低通滤波器 STLP104-N078（DC-10.4GHz） ..... （844） 点此查看规格书
低通滤波器 STLP105-M026（DC-10.5GHz） ..... （845） 点此查看规格书
低通滤波器 STLP108-N079（DC-10.9GHz） ..... （846） 点此查看规格书
低通滤波器 STLP115-M027（DC-11.5GHz） ..... （847） 点此查看规格书
低通滤波器 STLP116-M222（DC-11.6GHz） ..... （848） 点此查看规格书
低通滤波器 STLP116-M664（DC-11.6GHz） ..... （849） 点此查看规格书
低通滤波器 STLP118-N080（DC-11.8GHz） ..... （850） 点此查看规格书
低通滤波器 STLP126-N081（DC-12.6GHz） ..... （851） 点此查看规格书
低通滤波器 STLP130-M028（DC-13.0GHz） ..... （852） 点此查看规格书
低通滤波器 STLP132-M029（DC-13.2GHz） ..... （853） 点此查看规格书
低通滤波器 STLP134-N082（DC-13.4GHz） ..... （854） 点此查看规格书
低通滤波器 STLP140-M030（DC-14.0GHz） ..... （855） 点此查看规格书
低通滤波器 STLP142-N083（DC-14.2GHz） ..... （856） 点此查看规格书
低通滤波器 STLP146-M687（DC-14.6GHz） ..... （857） 点此查看规格书
低通滤波器 STLP148-M031（DC-14.8GHz） ..... （858） 点此查看规格书
低通滤波器 STLP150-N084（DC-15.0GHz） ..... （859） 点此查看规格书
低通滤波器 STLP152-N085（DC-15.2GHz） ..... （860） 点此查看规格书
低通滤波器 STLP160-M032（DC-16.0GHz） ..... （861） 点此查看规格书

电话：(+86)156 0809 5669 邮箱：sales@com-mw.com
传真：(+86)028 8408 5893 地址：四川省成都市成华区航天路118号4-3单元

微信扫码联系

低通滤波器	STLP166-N086（DC-16.6GHz）	……	（862）	点此查看规格书
低通滤波器	STLP168-M033（DC-16.8GHz）	……	（863）	点此查看规格书
低通滤波器	STLP170-K337（DC-17.0GHz）	……	（864）	点此查看规格书
低通滤波器	STLP172-M040（DC-17.2GHz）	……	（865）	点此查看规格书
低通滤波器	STLP173-N087（DC-17.3GHz）	……	（866）	点此查看规格书
低通滤波器	STLP174-M623（DC-17.4GHz）	……	（867）	点此查看规格书
低通滤波器	STLP180-K704（DC-18.0GHz）	……	（868）	点此查看规格书
低通滤波器	STLP180-M665（DC-18.0GHz）	……	（869）	点此查看规格书
低通滤波器	STLP182-K628（DC-18.2GHz）	……	（870）	点此查看规格书
低通滤波器	STLP186-M034（DC-18.6GHz）	……	（871）	点此查看规格书
低通滤波器	STLP186-N088（DC-18.6GHz）	……	（872）	点此查看规格书
低通滤波器	STLP190-N089（DC-19.0GHz）	……	（873）	点此查看规格书
低通滤波器	STLP196-M035（DC-19.6GHz）	……	（874）	点此查看规格书
低通滤波器	STLP200-K790（DC-20.0GHz）	……	（875）	点此查看规格书
低通滤波器	STLP204-N090（DC-20.4GHz）	……	（876）	点此查看规格书
低通滤波器	STLP205-K183（DC-20.5GHz）	……	（877）	点此查看规格书
低通滤波器	STLP205-M694（DC-20.5GHz）	……	（878）	点此查看规格书
低通滤波器	STLP212-N091（DC-21.2GHz）	……	（879）	点此查看规格书
低通滤波器	STLP225-M690（DC-22.5GHz）	……	（880）	点此查看规格书
低通滤波器	STLP228-N092（DC-22.8GHz）	……	（881）	点此查看规格书
低通滤波器	STLP230-K789（DC-23.0GHz）	……	（882）	点此查看规格书
低通滤波器	STLP236-N093（DC-23.6GHz）	……	（883）	点此查看规格书
低通滤波器	STLP238-K184（DC-23.8GHz）	……	（884）	点此查看规格书
低通滤波器	STLP240-N094（DC-24.0GHz）	……	（885）	点此查看规格书
低通滤波器	STLP245-M691（DC-24.5GHz）	……	（886）	点此查看规格书
低通滤波器	STLP248-M427（DC-24.8GHz）	……	（887）	点此查看规格书
低通滤波器	STLP260-K185（DC-26.0GHz）	……	（888）	点此查看规格书
低通滤波器	STLP262-M686（DC-26.2GHz）	……	（889）	点此查看规格书
低通滤波器	STLP262-N095（DC-26.0GHz）	……	（890）	点此查看规格书
低通滤波器	STLP265-M692（DC-26.5GHz）	……	（891）	点此查看规格书

电话：(+86)156 0809 5669　　邮箱：sales@com-mw.com
传真：(+86)028 8408 5893　　地址：四川省成都市成华区航天路118号4-3单元

微信扫码联系

低通滤波器	STLP274-N034（DC-27.4GHz）	.....	（892）	点此查看规格书
低通滤波器	STLP278-N096（DC-27.8GHz）	.....	（893）	点此查看规格书
低通滤波器	STLP280-K186（DC-28.0GHz）	.....	（894）	点此查看规格书
低通滤波器	STLP285-M693（DC-28.5GHz）	.....	（895）	点此查看规格书
低通滤波器	STLP292-N097（DC-29.2GHz）	.....	（896）	点此查看规格书
低通滤波器	STLP295-K188（DC-29.5GHz）	.....	（897）	点此查看规格书
低通滤波器	STLP300-K187（DC-30.0GHz）	.....	（898）	点此查看规格书
低通滤波器	STLP310-N098（DC-31.0GHz）	.....	（899）	点此查看规格书
低通滤波器	STLP320-M624（DC-32.0GHz）	.....	（900）	点此查看规格书
低通滤波器	STLP332-N099（DC-33.0GHz）	.....	（901）	点此查看规格书
低通滤波器	STLP335-K192（DC-33.5GHz）	.....	（902）	点此查看规格书
低通滤波器	STLP348-N100（DC-34.8GHz）	.....	（903）	点此查看规格书
低通滤波器	STLP355-K193（DC-35.5GHz）	.....	（904）	点此查看规格书
低通滤波器	STLP368-K194（DC-36.8GHz）	.....	（905）	点此查看规格书
低通滤波器	STLP380-K195（DC-38.0GHz）	.....	（906）	点此查看规格书
低通滤波器	STLP380-N279（DC-38.0GHz）	.....	（907）	点此查看规格书
低通滤波器	STLP420-K775（DC-42.0GHz）	.....	（908）	点此查看规格书
低通滤波器	STLP440-N280（DC-44.0GHz）	.....	（909）	点此查看规格书
低通滤波器	STLP460-N203（DC-46.0GHz）	.....	（910）	点此查看规格书
带阻滤波器	STRP3R5-0R0-K633（3.5GHz）	.....	（911）	点此查看规格书
带阻滤波器	STRP3R6-0R0-M231（3.6GHz）	.....	（912）	点此查看规格书
带阻滤波器	STRP4R3-0R0-K925（4.3GHz）	.....	（913）	点此查看规格书
带阻滤波器	STRP4R3-0R0-M233（4.3GHz）	.....	（914）	点此查看规格书
带阻滤波器	STRP4R3-0R0-N167（4.3GHz）	.....	（915）	点此查看规格书
带阻滤波器	STRP5R1-0R0-M232（5.1GHz）	.....	（916）	点此查看规格书
带阻滤波器	STRP5R3-0R0-N533（5.3GHz）	.....	（917）	点此查看规格书
带阻滤波器	STRP9R4-0R0-N595（9.4GHz）	.....	（918）	点此查看规格书
带阻滤波器	STRP141-0R8-N502（13.75-14.5GHz）	.....	（919）	点此查看规格书
带阻滤波器	STRP143-0R5-N502（14.0-14.5GHz）	.....	（920）	点此查看规格书
带阻滤波器	STRP295-3R0-K927（28.0-31.0GHz）	.....	（921）	点此查看规格书

电话：(+86)156 0809 5669　　邮箱：sales@com-mw.com
传真：(+86)028 8408 5893　　地址：四川省成都市成华区航天路118号4-3单元

微信扫码联系

产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

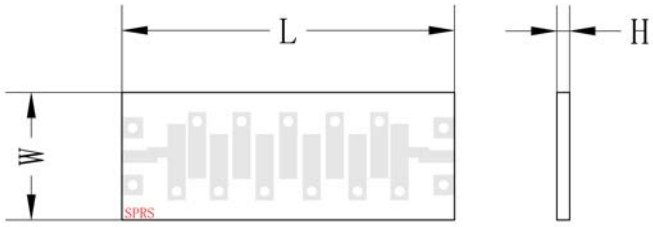
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	2.7	GHz
工作带宽	1.8-3.6	GHz
中心损耗	2.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-1.0GHz	dBc
带外抑制	40@5.4-10.5GHz	dBc

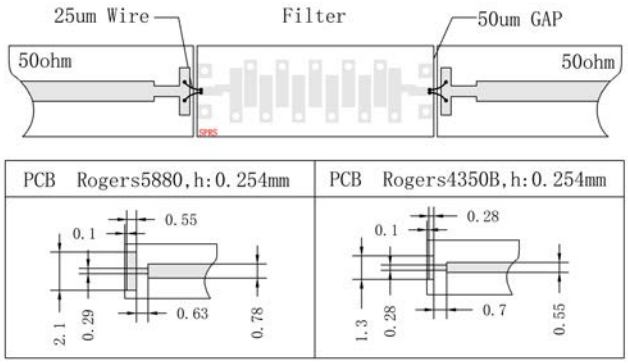
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：12.0，W：6.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



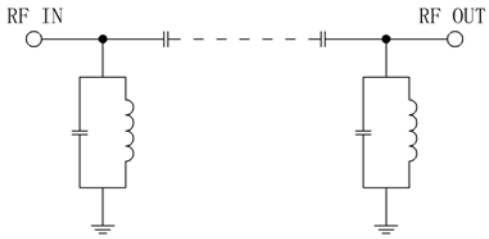
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

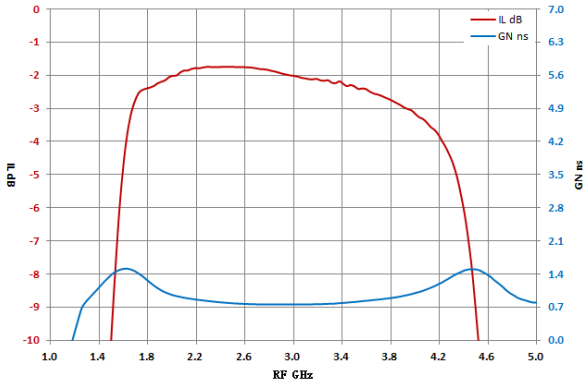
参考实物图

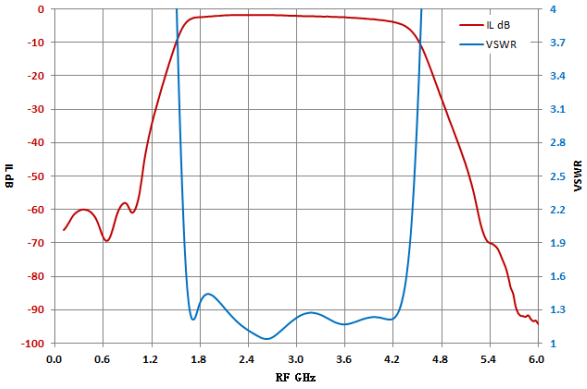


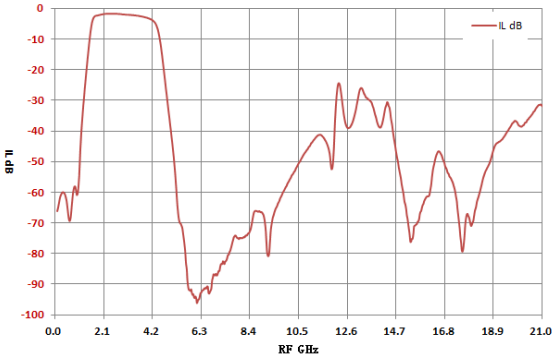
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

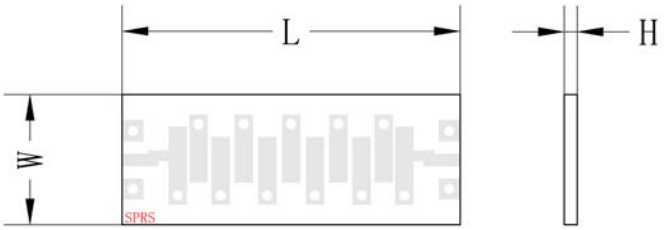
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	2.55	GHz
工作带宽	2.05-3.05	GHz
中心损耗	2.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	1.2	ns
带外抑制	55@DC-1.4GHz	dBc
带外抑制	40@3.8-11.0GHz	dBc

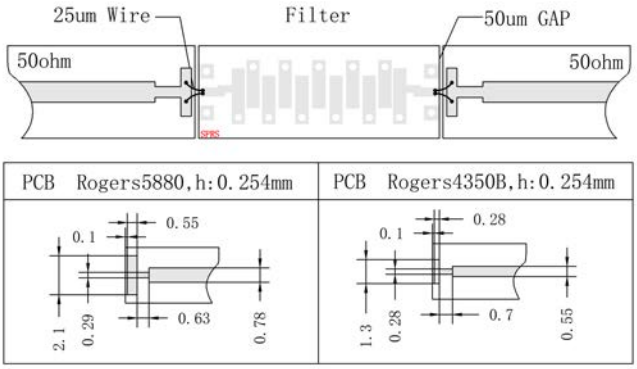
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：12.0，W：6.5，h：0.39

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.61mm,端口可互换;

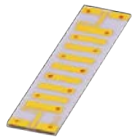
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

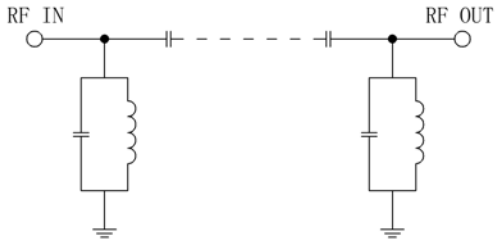
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

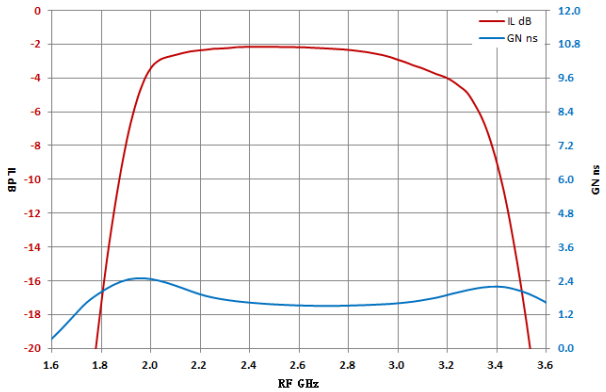
参考图

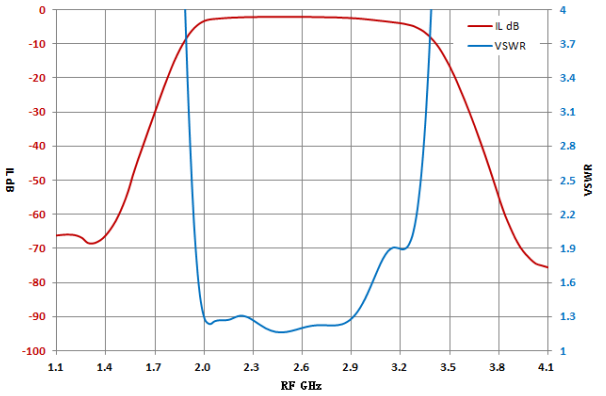


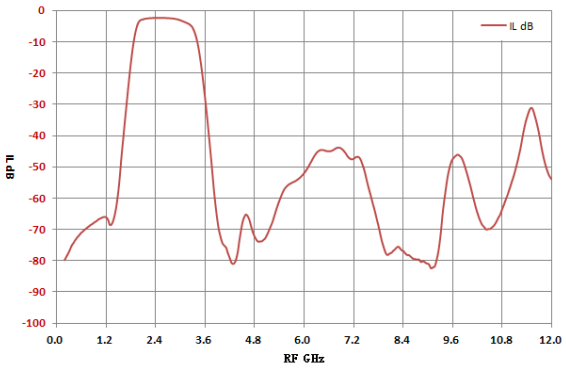
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



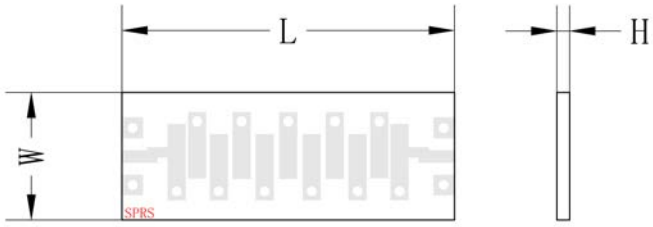
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	2.5	GHz
工作带宽	2.2-2.8	GHz
中心损耗	2.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-1.4GHz	dBc
带外抑制	30@3.7-8.0GHz	dBc

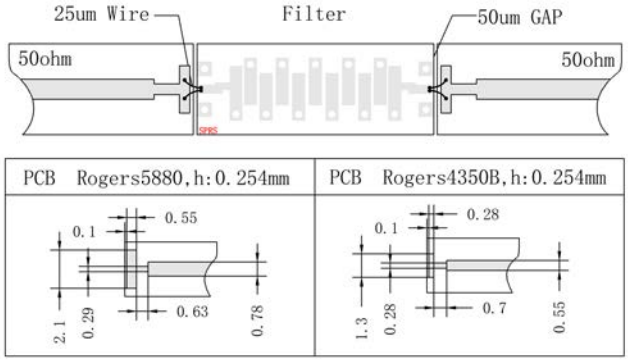
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：12.0，W：5.5，h：0.39

外形图：端口居中



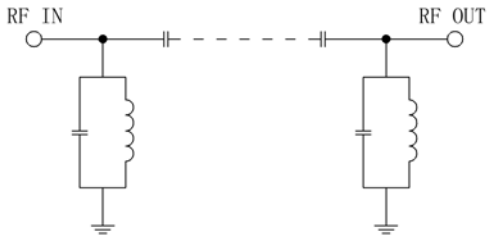
推荐装配图



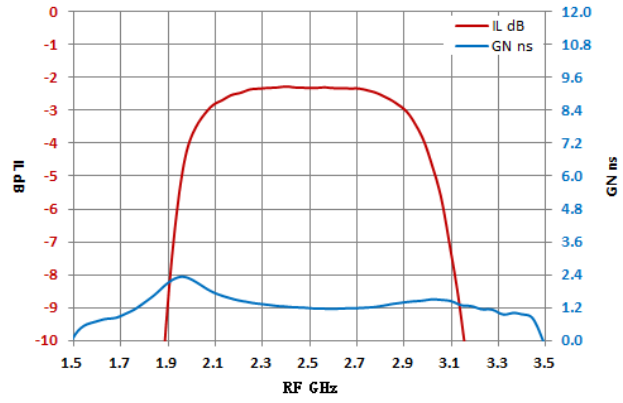
注意事项

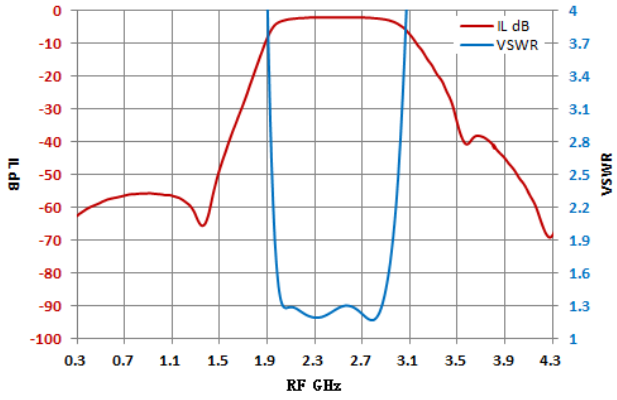
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.62mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

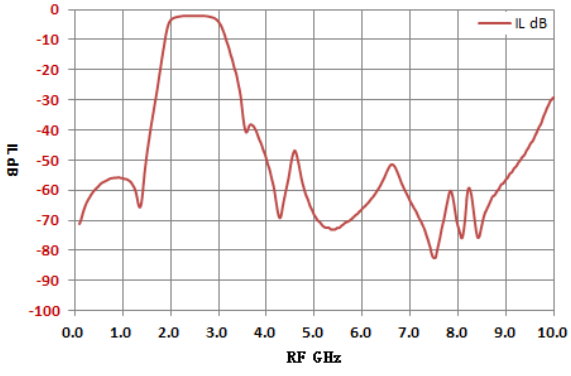
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

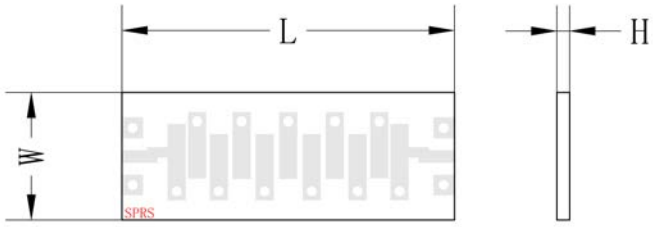
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	2.8	GHz
工作带宽	2.25-3.35	GHz
中心损耗	3.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-1.5GHz	dBc
带外抑制	40@4.3-10.0GHz	dBc

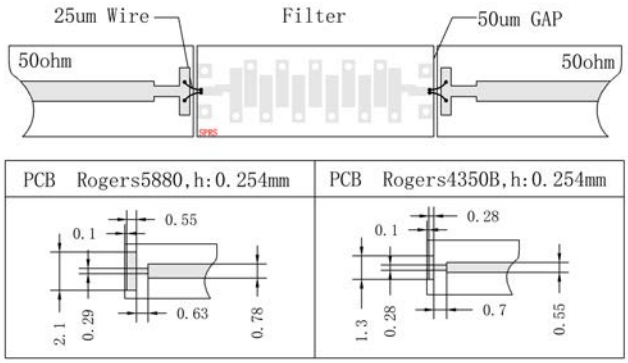
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.5，W：6.5，h：0.39

外形图：端口居中



推荐装配图



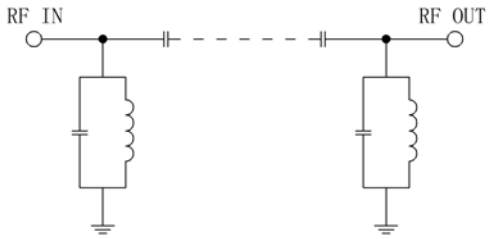
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.61mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

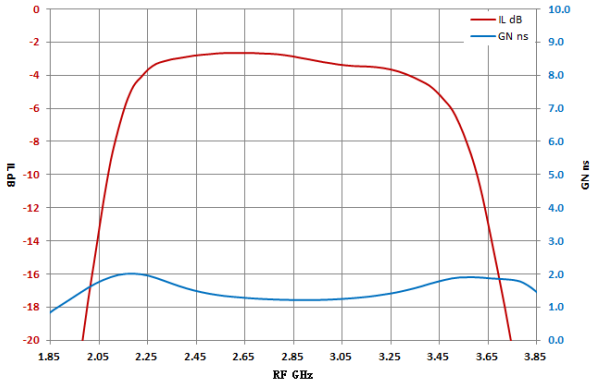
参考实物图

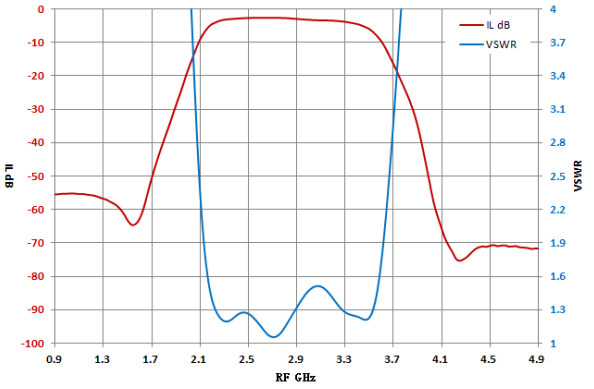


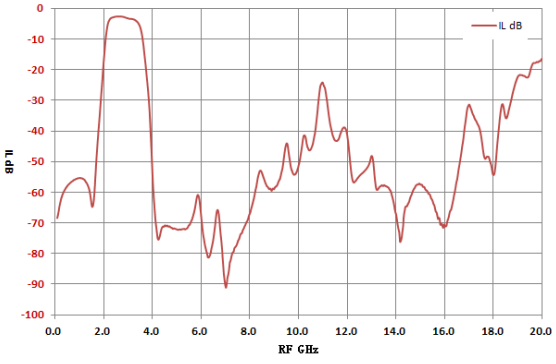
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



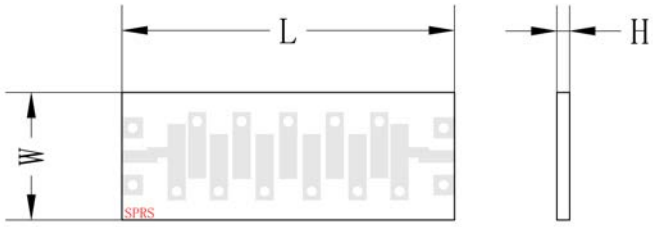
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	2.5	GHz
工作带宽	2.3-2.7	GHz
中心损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-1.75GHz	dBc
带外抑制	40@3.5-4.0GHz	dBc

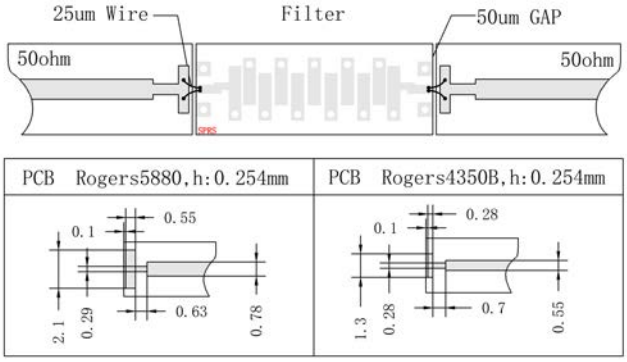
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：8.0，h：0.39

外形图：端口居中



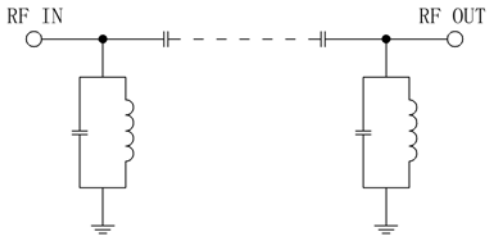
推荐装配图



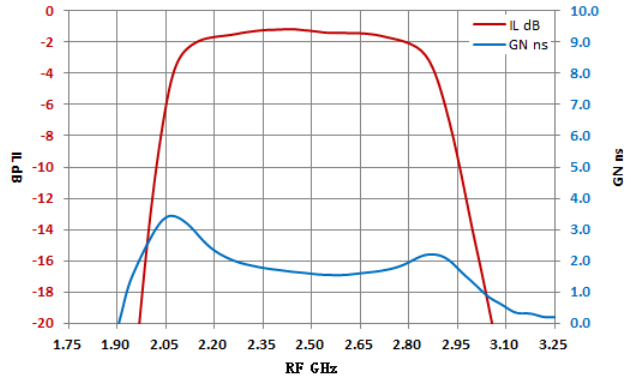
注意事项

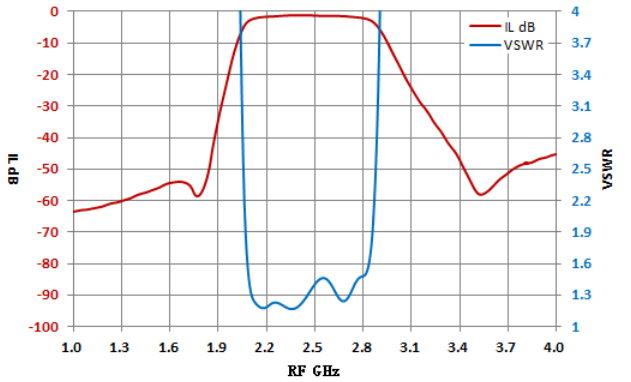
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

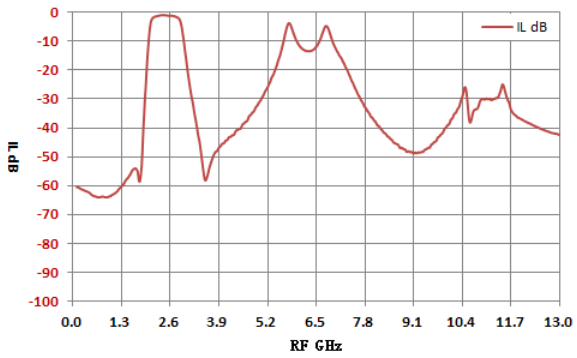
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



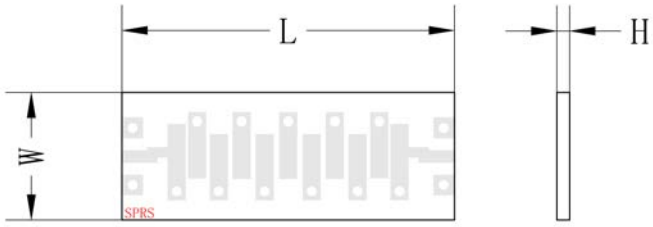
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	2.5	GHz
工作带宽	2.45-2.55	GHz
中心损耗	3.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	35@DC-2.1GHz	dBc
带外抑制	30@2.9-6.0GHz	dBc

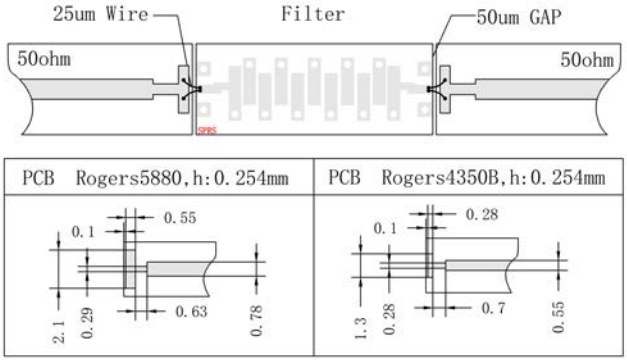
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：6.5，h：0.39

外形图：端口居中



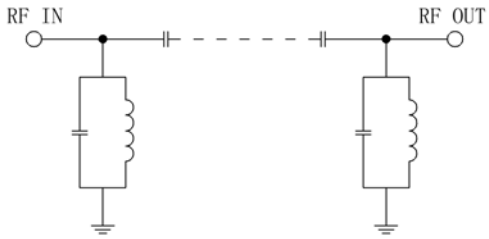
推荐装配图



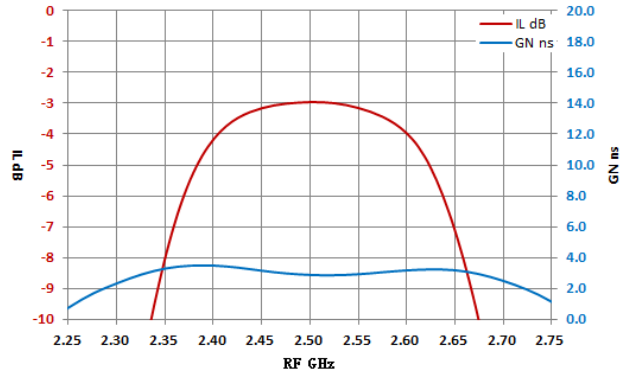
注意事项

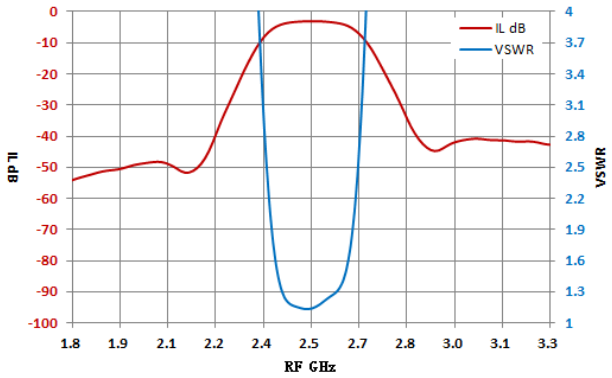
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.62mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

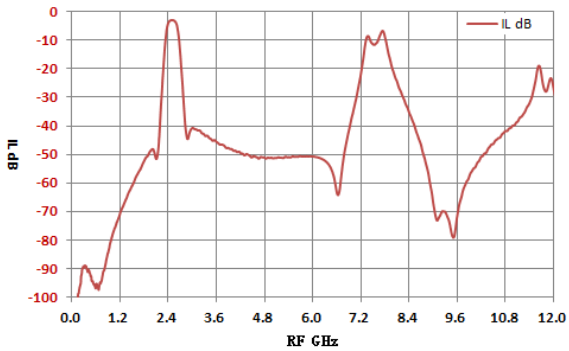
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



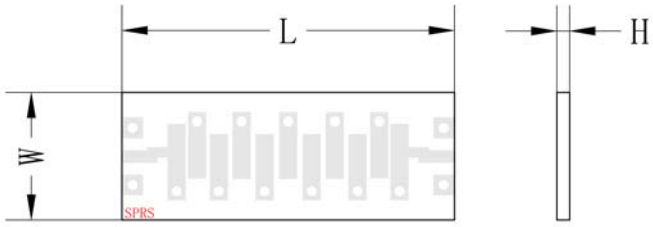
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	2.48	GHz
工作带宽	0	GHz
中心损耗	4.9	dB
带内波动	0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0	ns
带外抑制	30@DC-2.2GHz	dBc
带外抑制	30@2.8-6.5GHz	dBc

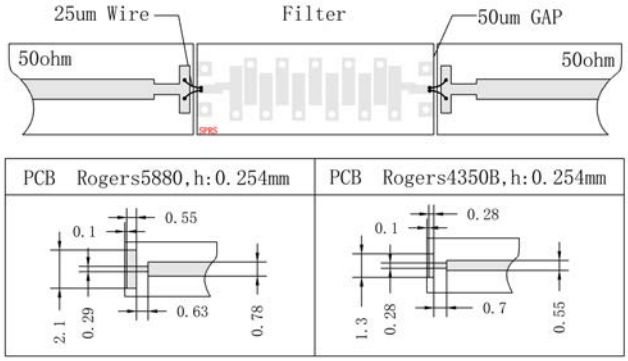
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：6.5，h：0.39

外形图：端口居中



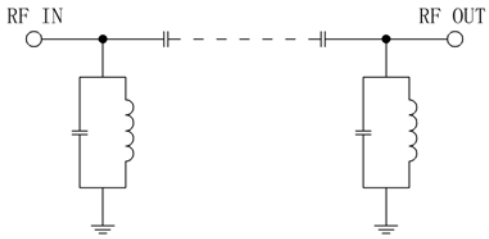
推荐装配图



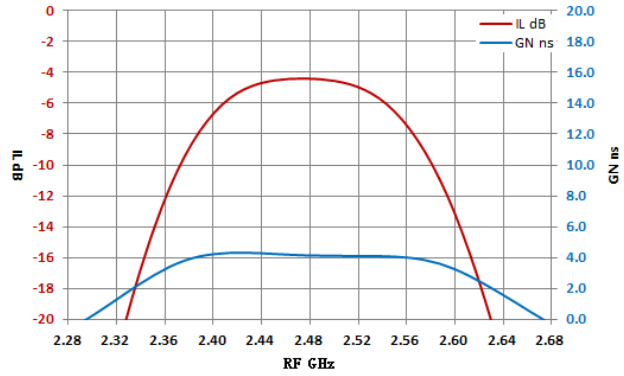
注意事项

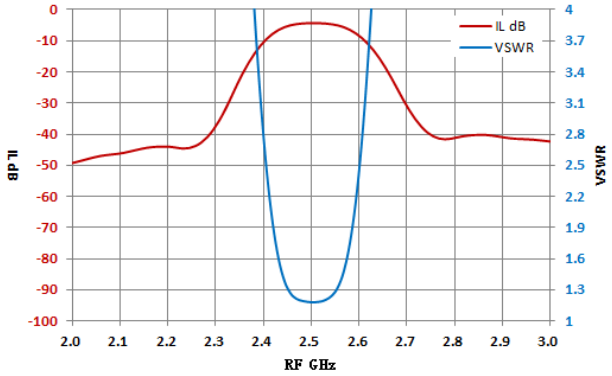
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.62mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

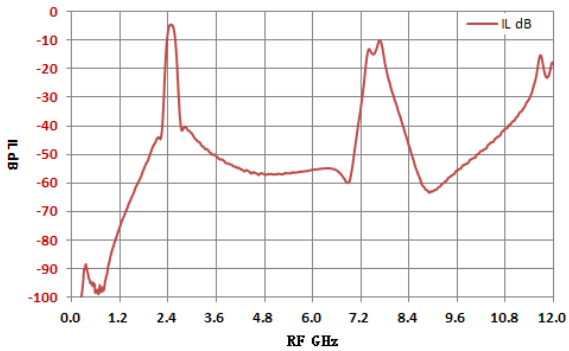
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



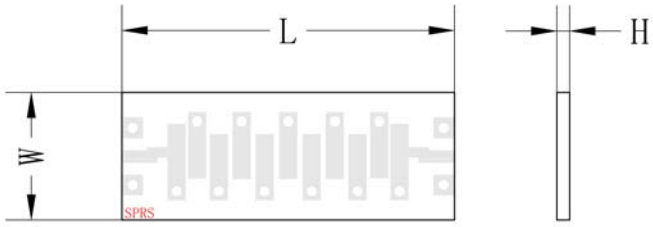
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	2.9	GHz
工作带宽	2.6-3.1	GHz
中心损耗	3.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-1.8GHz	dBc
带外抑制	40@4.0-6.0GHz	dBc

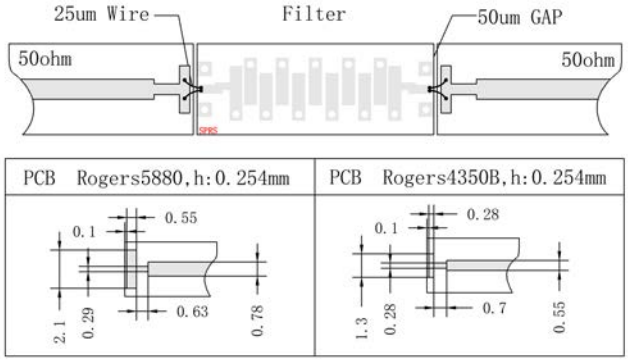
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：10.0，h：0.26

外形图：端口居中



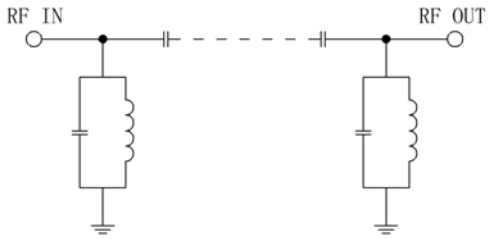
推荐装配图



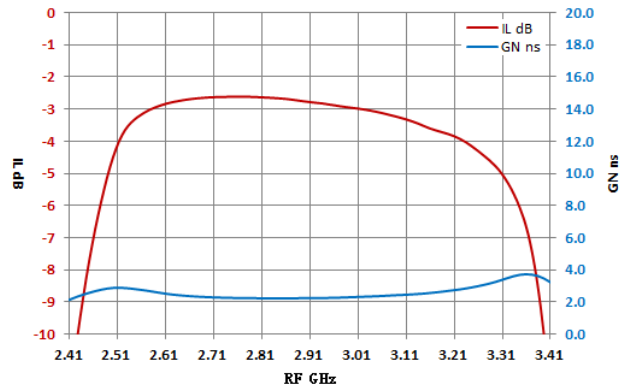
注意事项

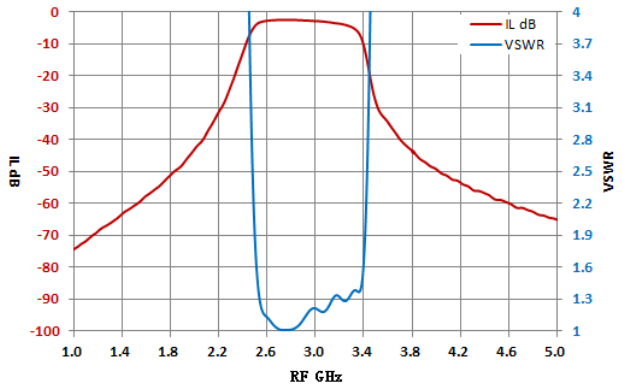
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

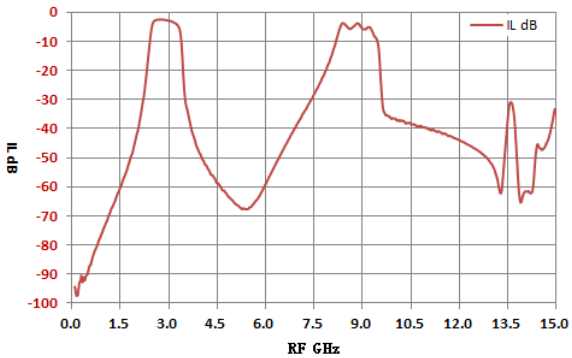
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

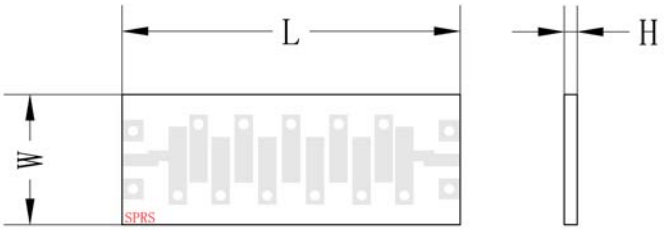
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	2.8	GHz
工作带宽	2.65-2.85	GHz
中心损耗	3.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.5:1	
群时延波动	0.6	ns
带外抑制	40@DC-2.3GHz	dBc
带外抑制	40@3.3-6.5GHz	dBc

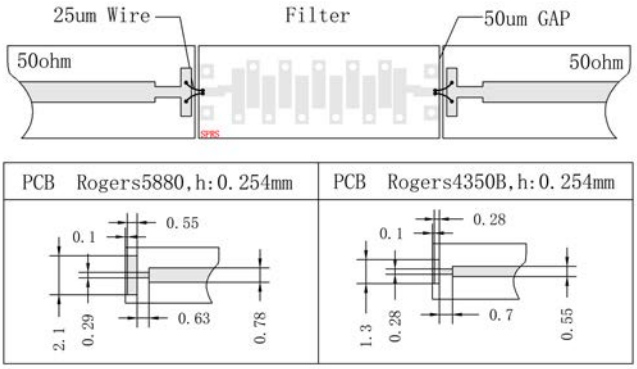
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：8.5，W：4.5，h：0.39

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.61mm,端口可互换;

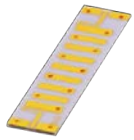
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

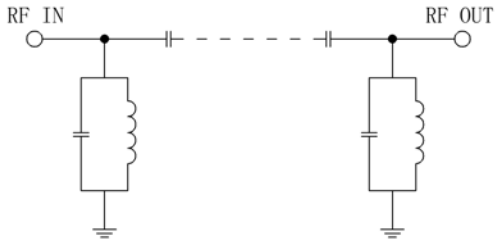
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

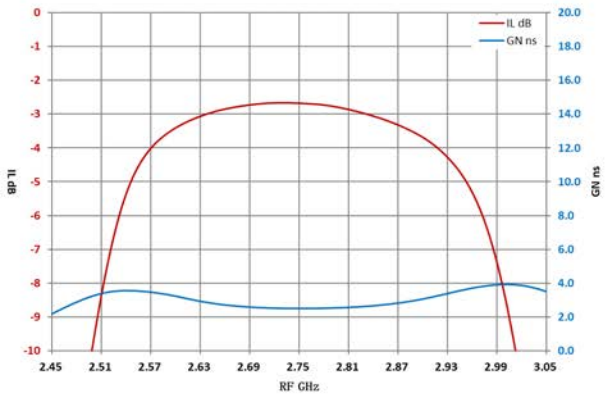
参考图

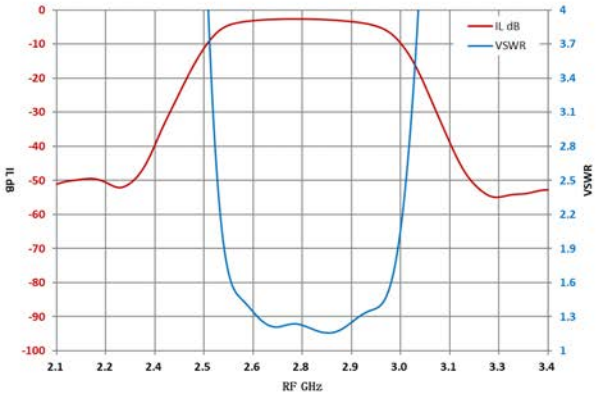


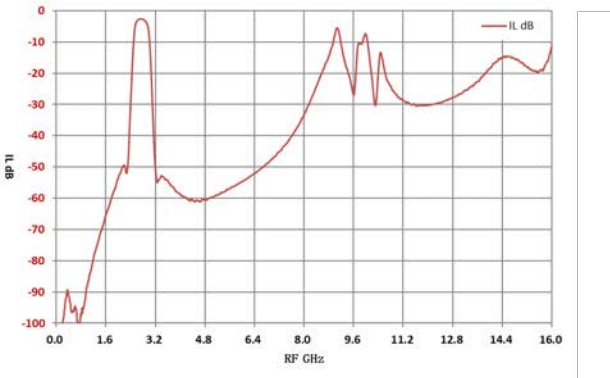
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



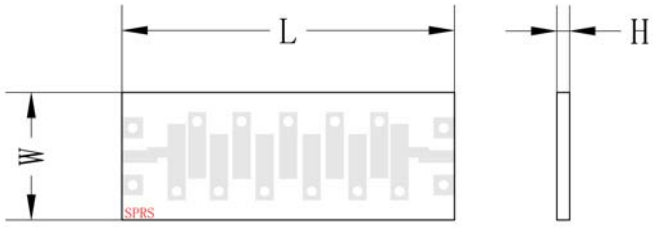
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	2.7	GHz
工作带宽	0	GHz
中心损耗	4.5	dB
带内波动	0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0	ns
带外抑制	30@DC-2.45GHz	dBc
带外抑制	30@3.0-7.0GHz	dBc

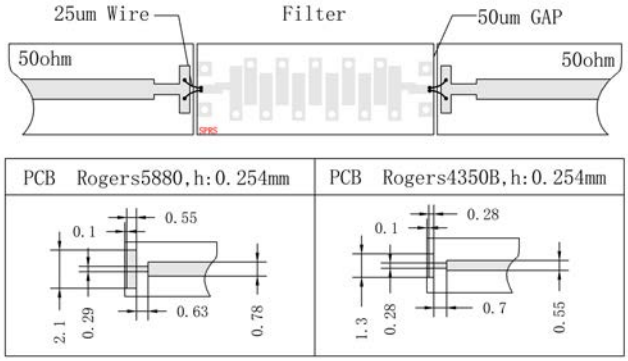
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：6.2，h：0.39

外形图：端口居中



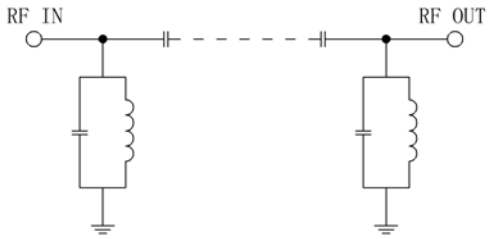
推荐装配图



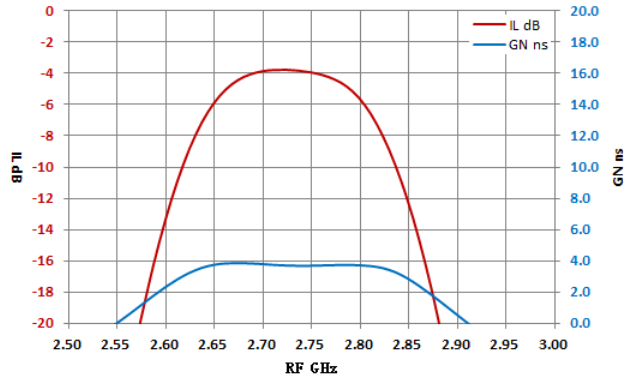
注意事项

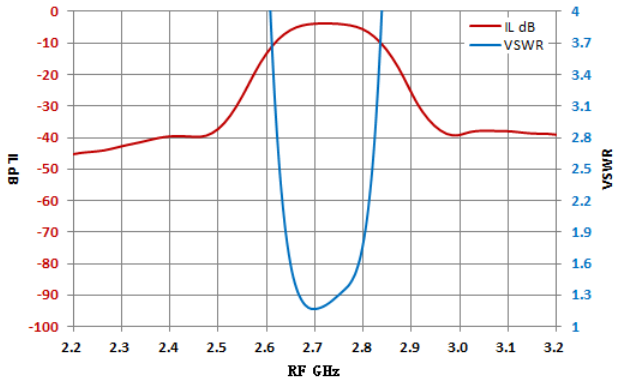
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

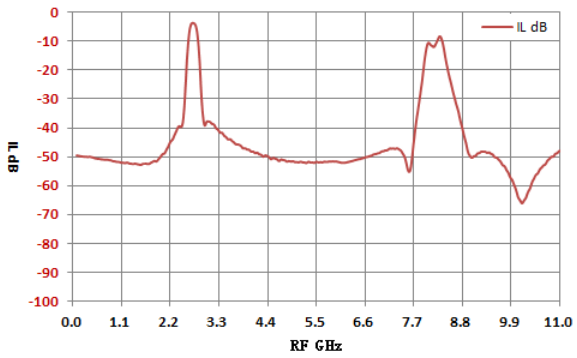
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

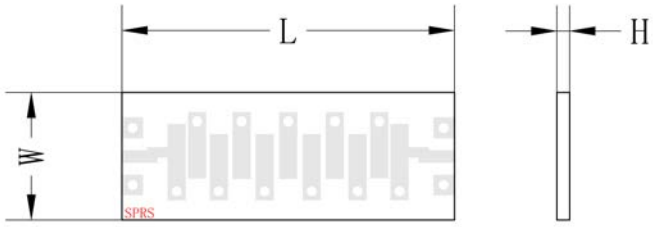
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	3.6	GHz
工作带宽	2.7-4.5	GHz
中心损耗	1.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-1.6GHz	dBc
带外抑制	40@6.1-11.0GHz	dBc

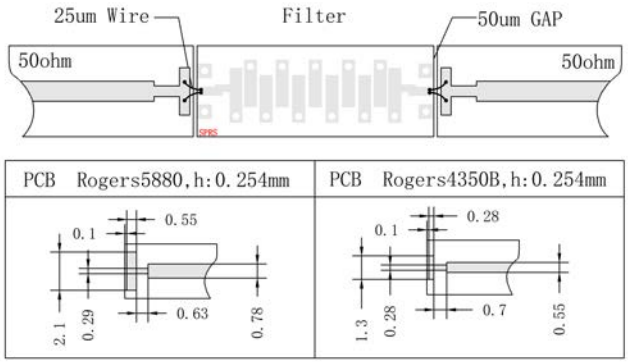
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：12.0，W：5.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



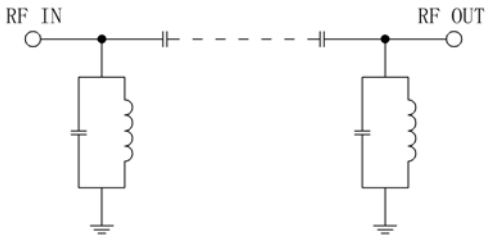
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

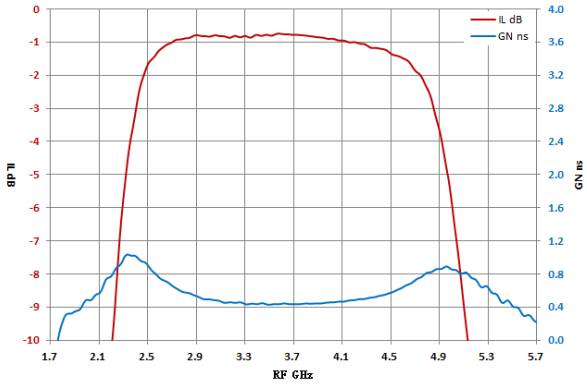
参考实物图

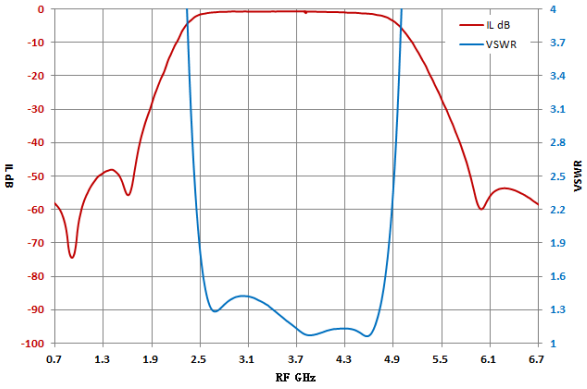


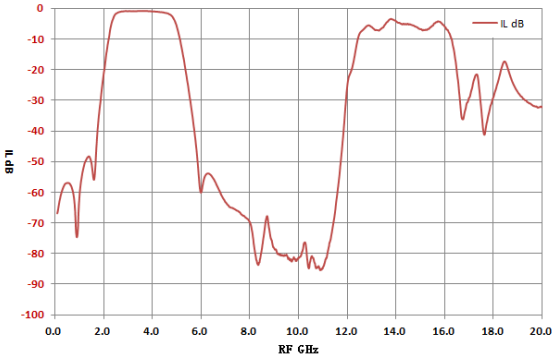
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



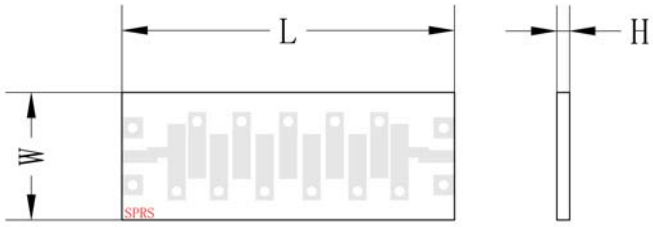
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	4.2	GHz
工作带宽	2.7-5.7	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	35@DC-1.7GHz	dBc
带外抑制	40@8.0-13.0GHz	dBc

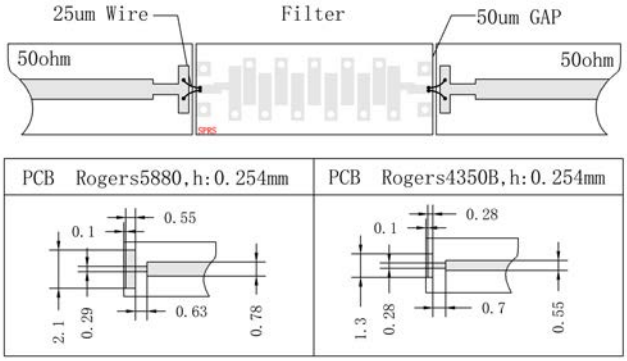
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：12.0，W：5.0，h：0.26

外形图：端口居中



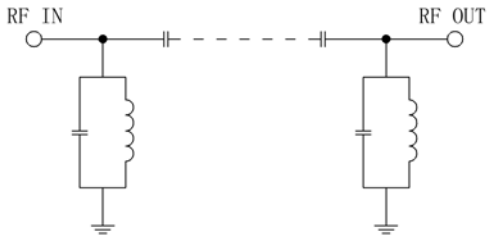
推荐装配图



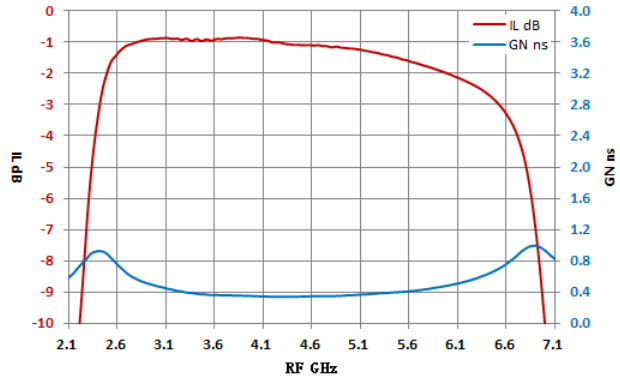
注意事项

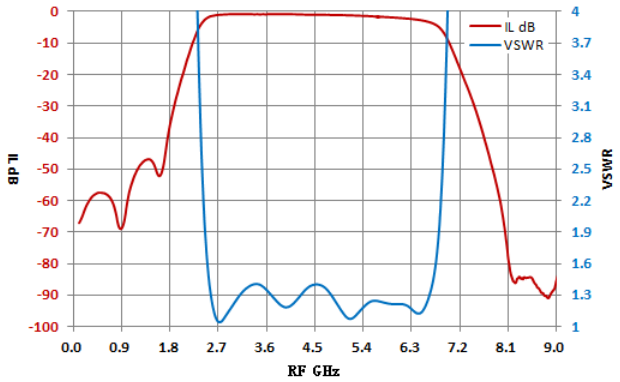
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

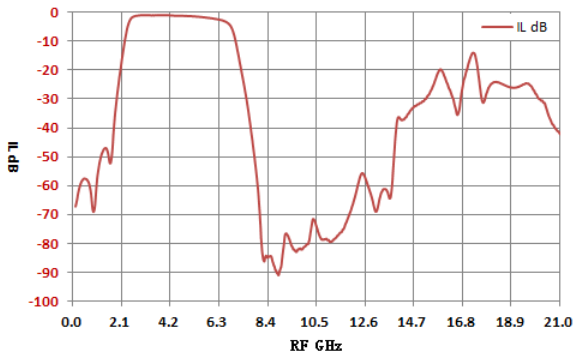
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

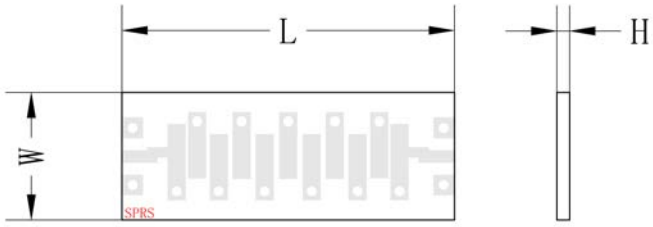
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	4.6	GHz
工作带宽	2.7-6.5	GHz
中心损耗	3.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	1.0	ns
带外抑制	40@DC-1.5GHz	dBc
带外抑制	40@8.8-11.0GHz	dBc

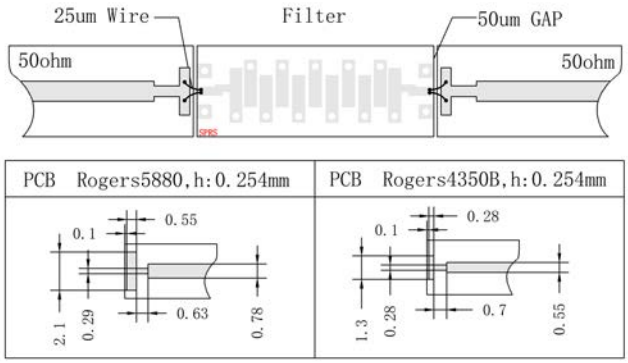
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：5.5，W：5.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



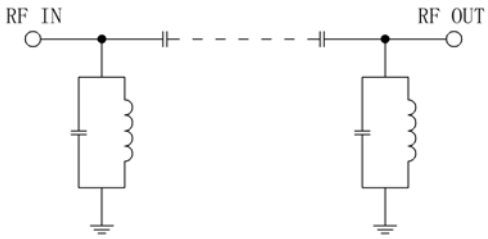
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

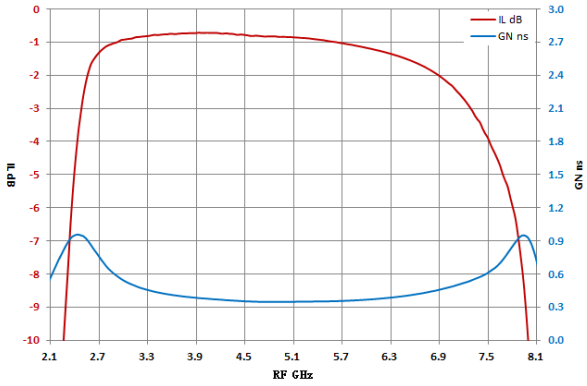
参考实物图

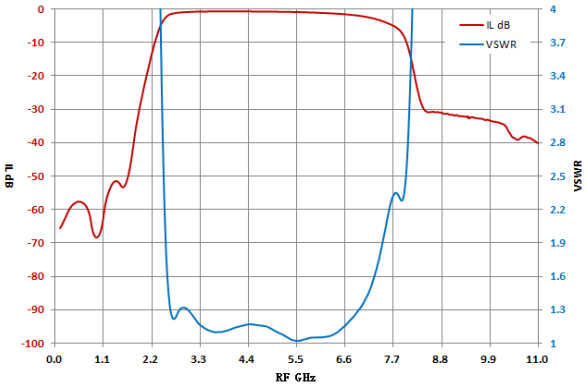


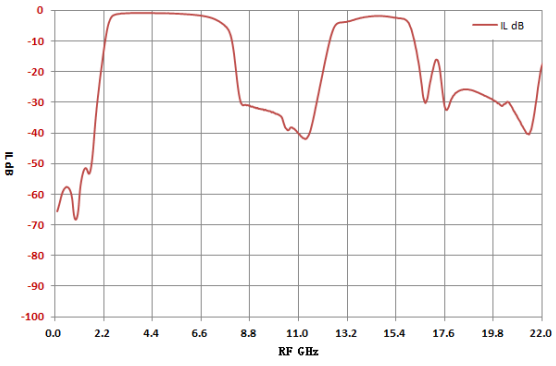
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

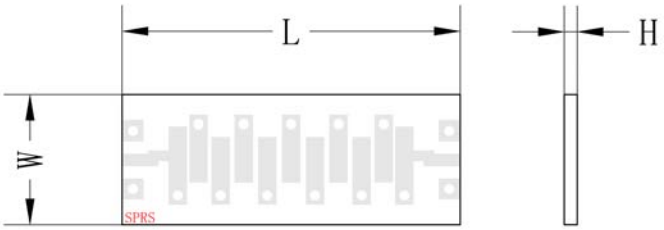
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	2.9	GHz
工作带宽	2.75-2.95	GHz
中心损耗	3.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.5:1	
群时延波动	0.6	ns
带外抑制	40@DC-2.4GHz	dBc
带外抑制	40@3.4-6.5GHz	dBc

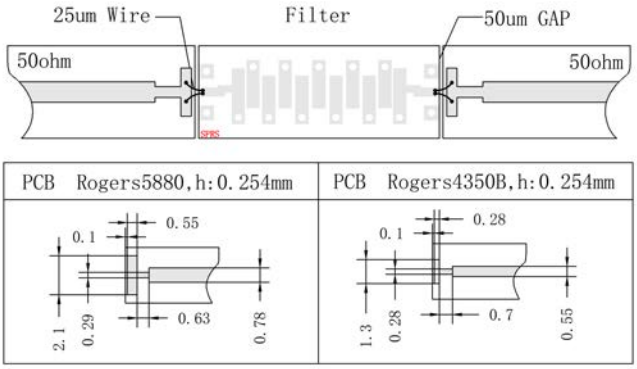
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：8.0，W：4.5，h：0.39

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.61mm,端口可互换;

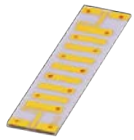
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

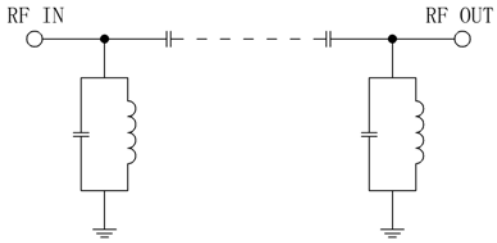
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

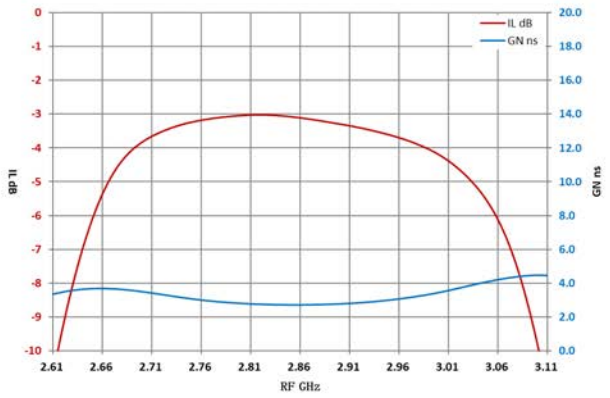
参考图

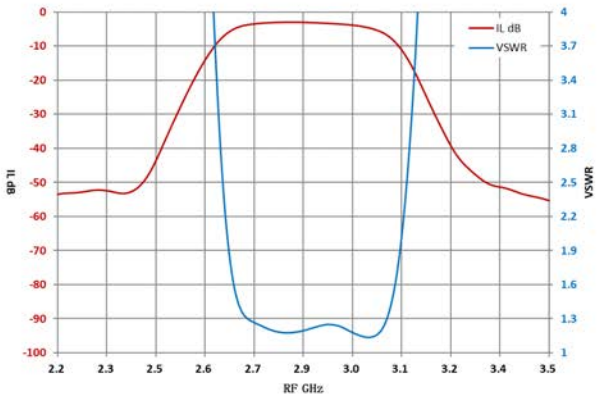


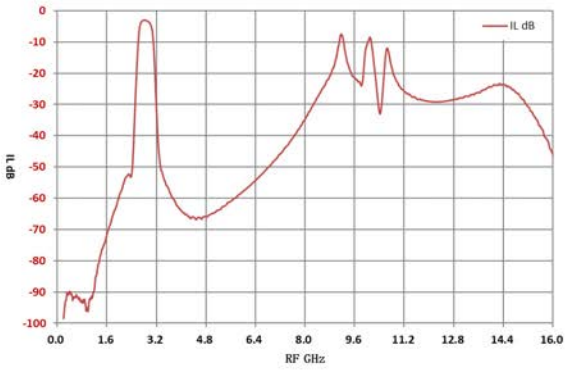
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

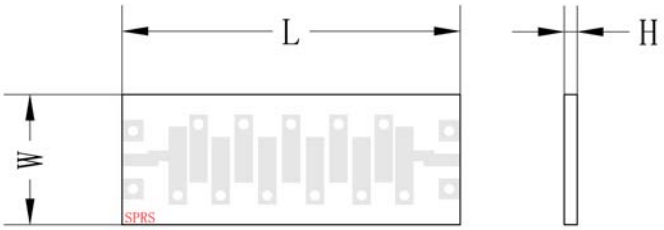
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	2.9	GHz
工作带宽	2.8-3.0	GHz
中心损耗	3.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.5:1	
群时延波动	0.6	ns
带外抑制	40@DC-2.5GHz	dBc
带外抑制	40@3.5-7.0GHz	dBc

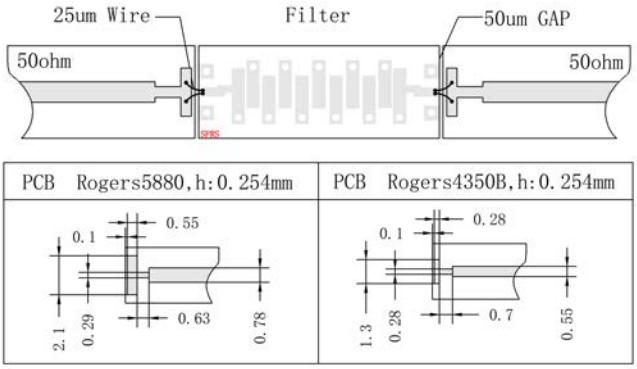
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：8.0，W：4.6，h：0.39

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.61mm,端口可互换;

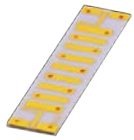
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

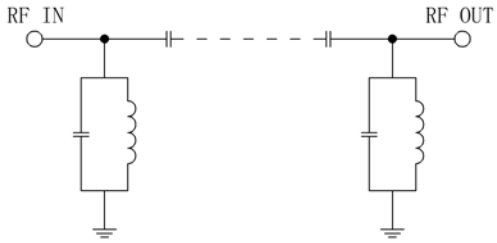
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

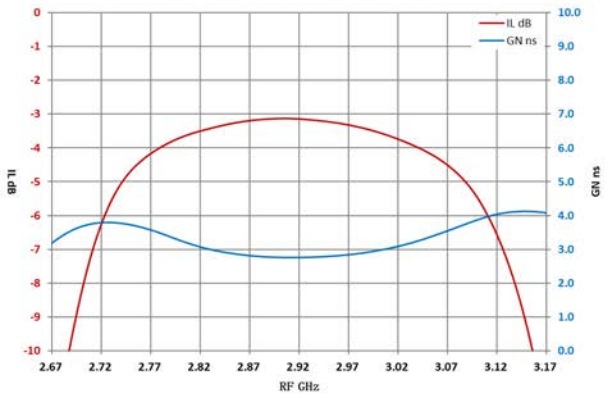
参考图

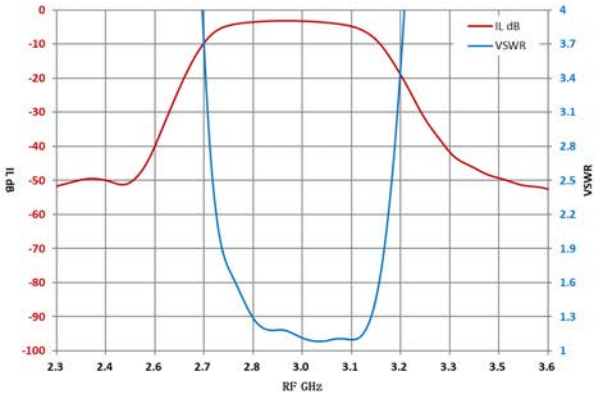


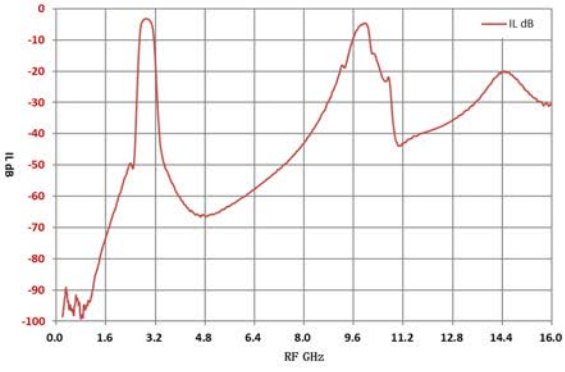
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

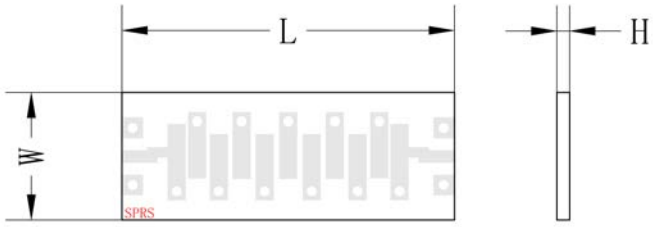
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	3.4	GHz
工作带宽	2.8-4.0	GHz
中心损耗	2.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-2.2GHz	dBc
带外抑制	40@4.7-8.0GHz	dBc

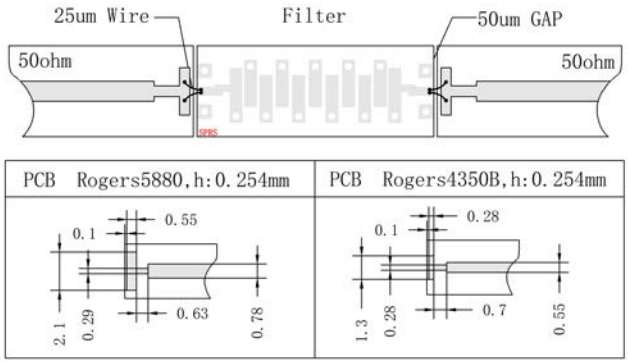
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：6.2，h：0.39

外形图：端口居中



推荐装配图



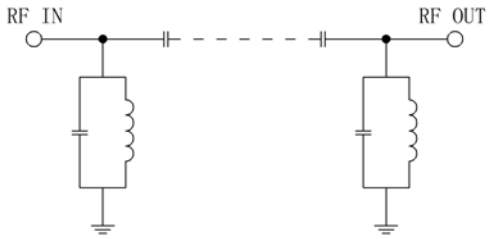
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.61mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

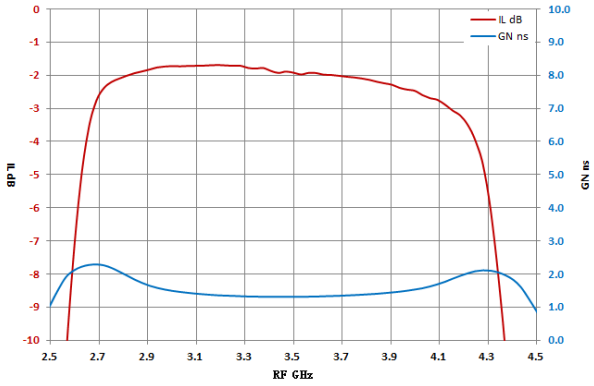
参考实物图

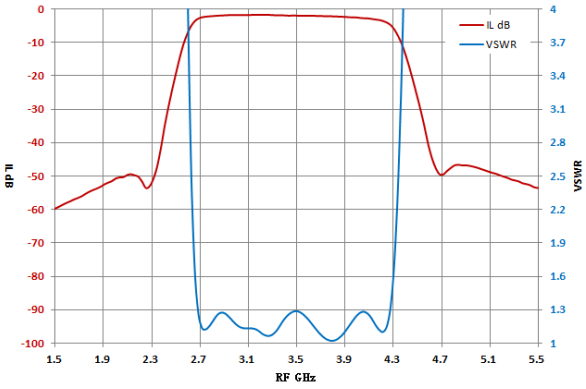


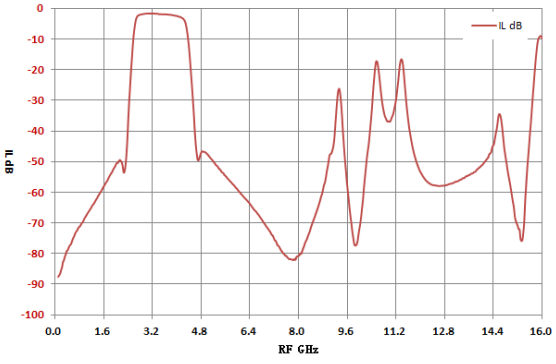
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



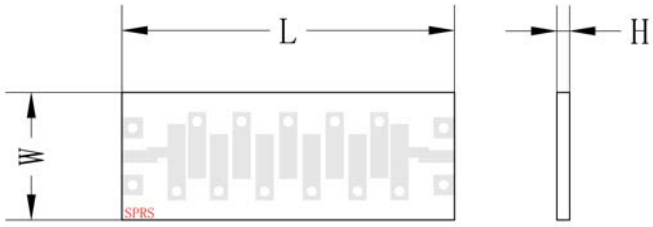
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	2.9	GHz
工作带宽	2.85-2.95	GHz
中心损耗	3.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.6	ns
带外抑制	40@DC-2.4GHz	dBc
带外抑制	35@3.3-7.0GHz	dBc

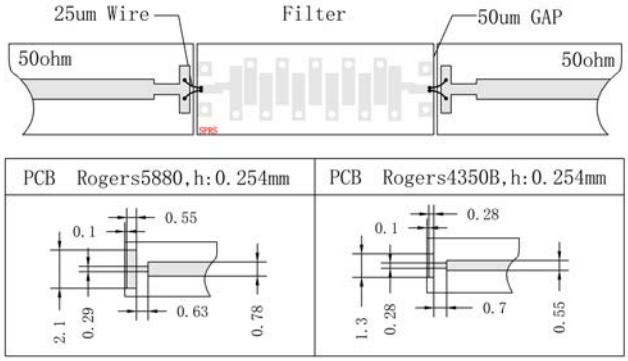
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：6.0，h：0.39

外形图：端口居中



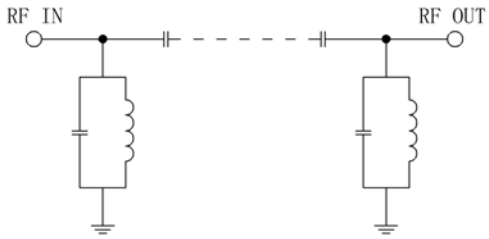
推荐装配图



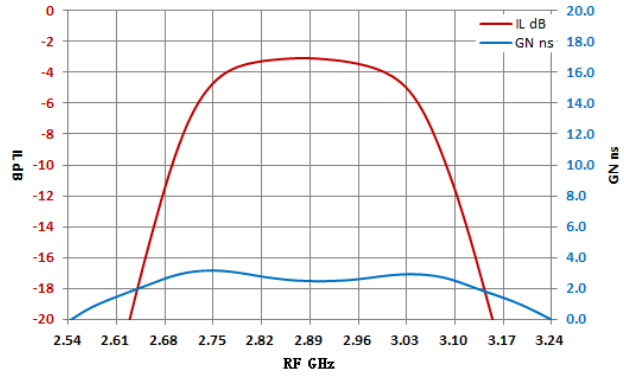
注意事项

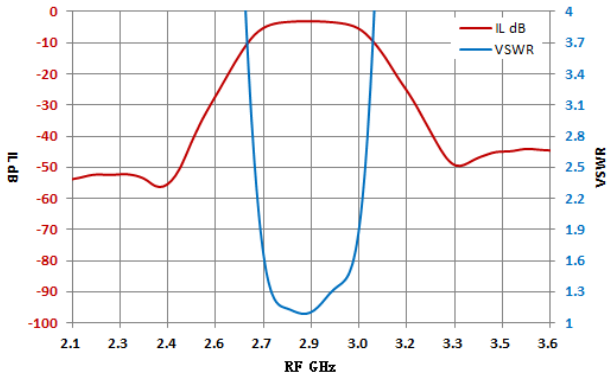
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.62mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

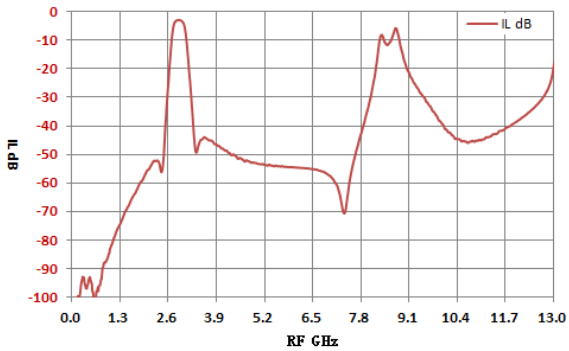
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

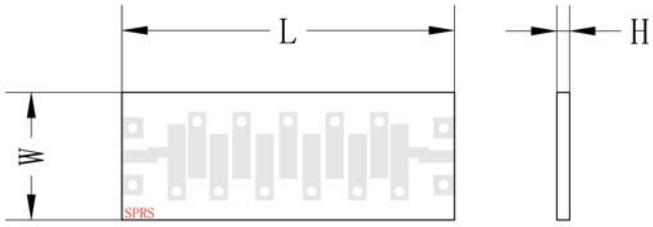
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	3.4	GHz
工作带宽	2.9-.3.9	GHz
中心损耗	1.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	1.0	ns
带外抑制	40@DC-2.0GHz	dBc
带外抑制	40@5.1-7.5GHz	dBc

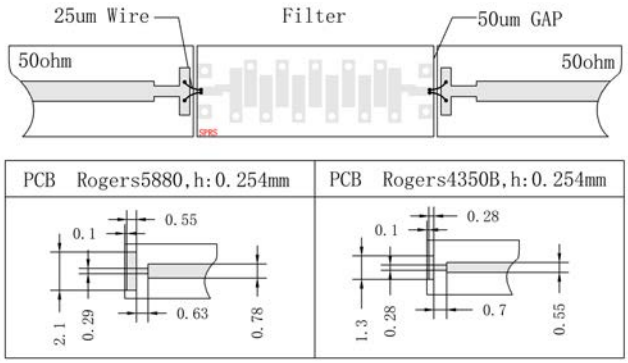
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：6.2，h：0.39

外形图：端口居中



推荐装配图



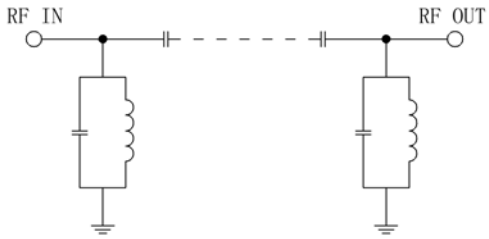
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

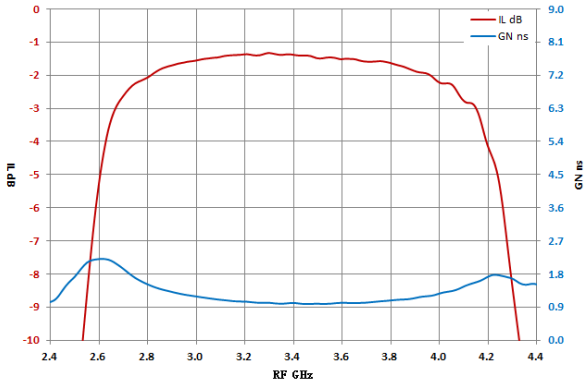
参考实物图

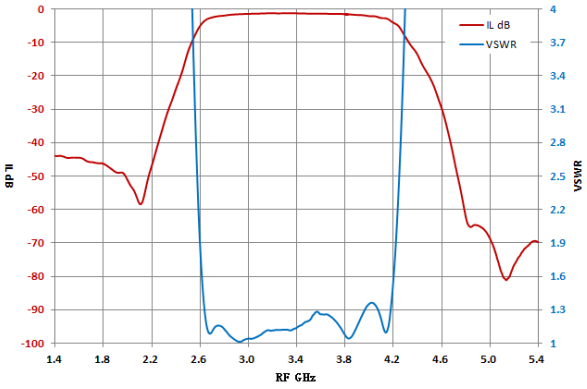


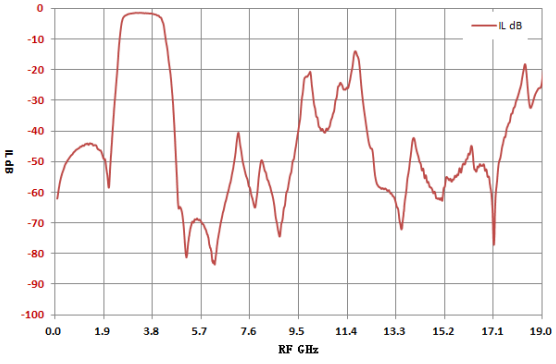
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



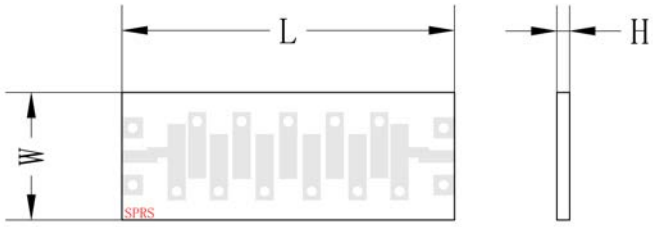
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	3.6	GHz
工作带宽	2.9-4.3	GHz
中心损耗	2.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-1.8GHz	dBc
带外抑制	35@5.5-8.5GHz	dBc

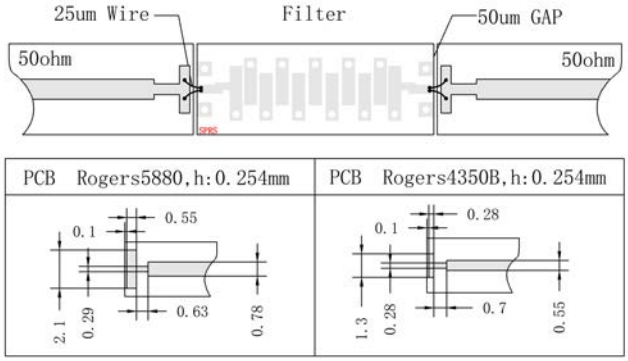
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：10.0，W：5.5，h：0.26

外形图：端口居中



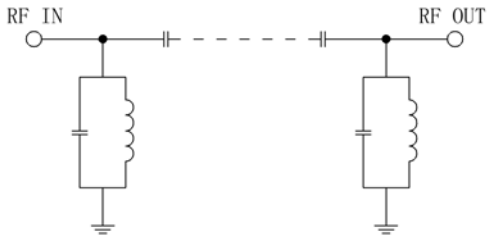
推荐装配图



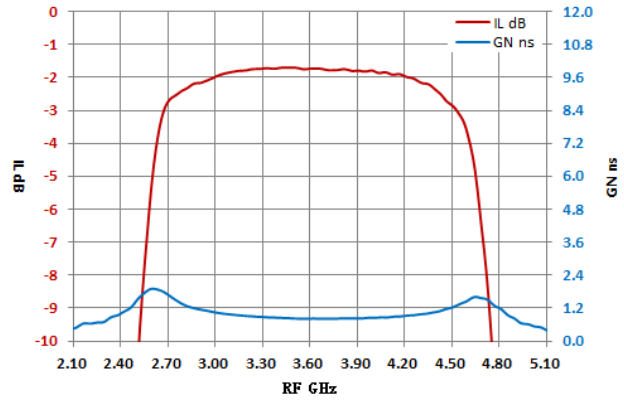
注意事项

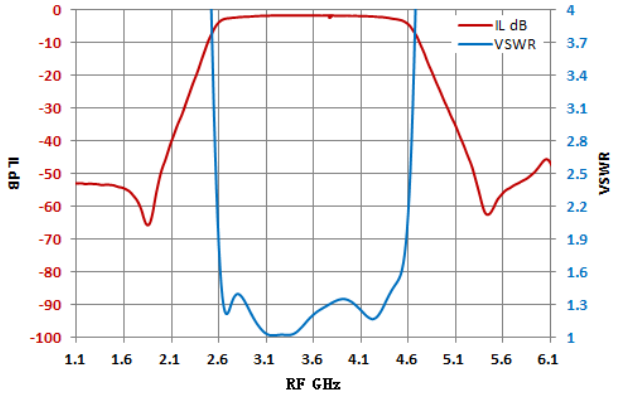
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

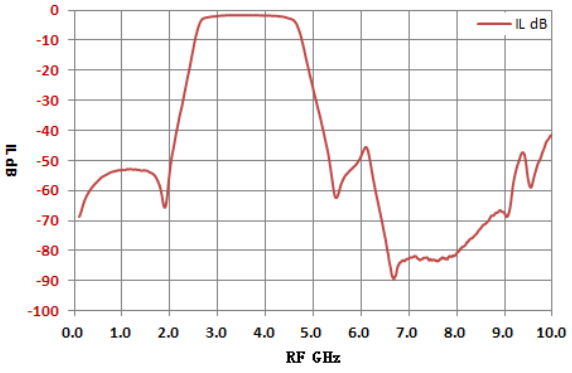
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



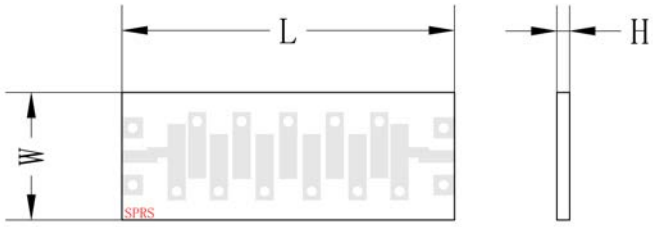
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	3.9	GHz
工作带宽	2.9-4.8	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.8:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-1.7GHz	dBc
带外抑制	40@6.2-9.5GHz	dBc

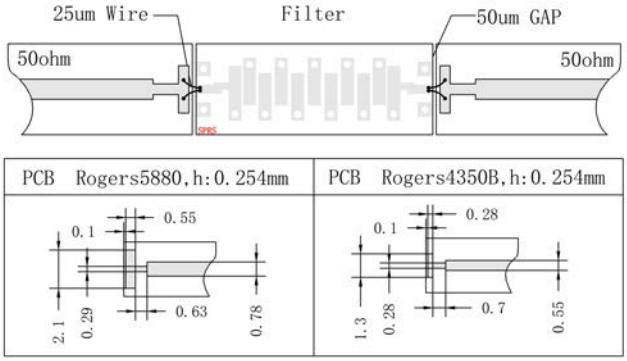
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：12.0，W：5.0，h：0.26

外形图：端口居中



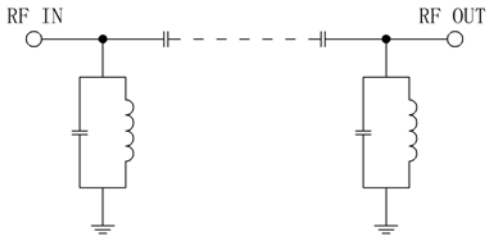
推荐装配图



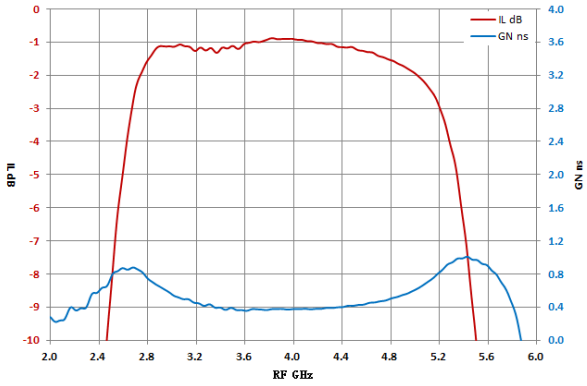
注意事项

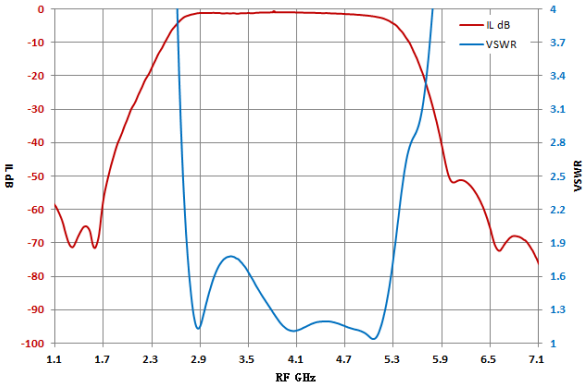
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

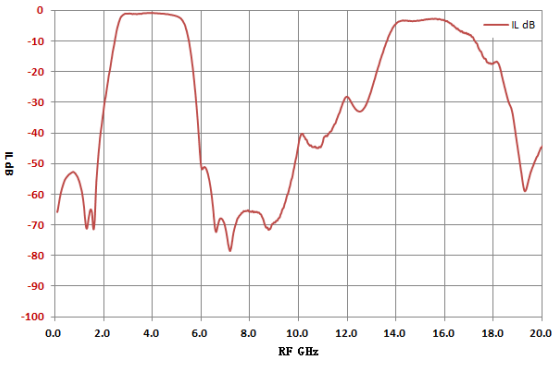
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



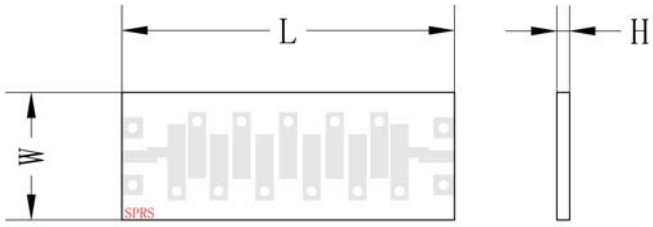
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	3.0	GHz
工作带宽	2.92-3.02	GHz
中心损耗	4.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-2.5GHz	dBc
带外抑制	40@3.5-7.5GHz	dBc

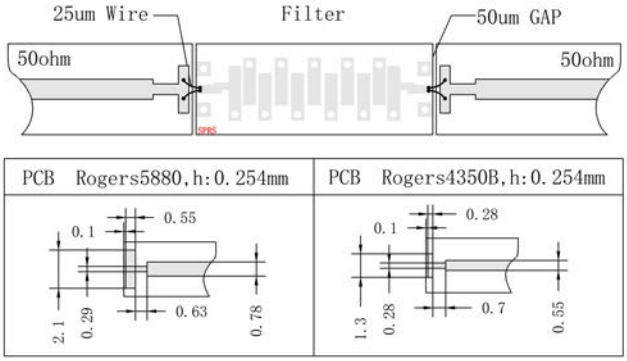
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：6.0，h：0.39

外形图：端口居中



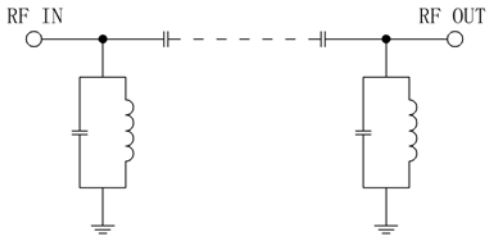
推荐装配图



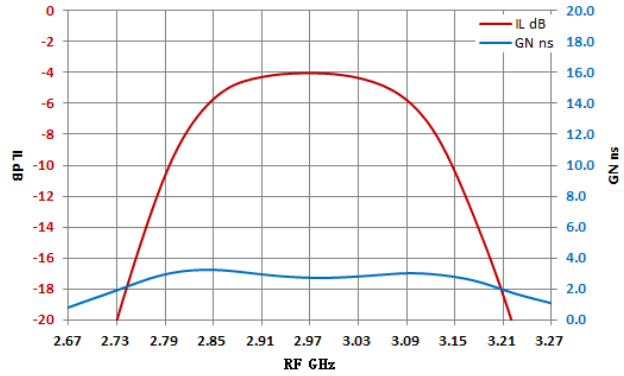
注意事项

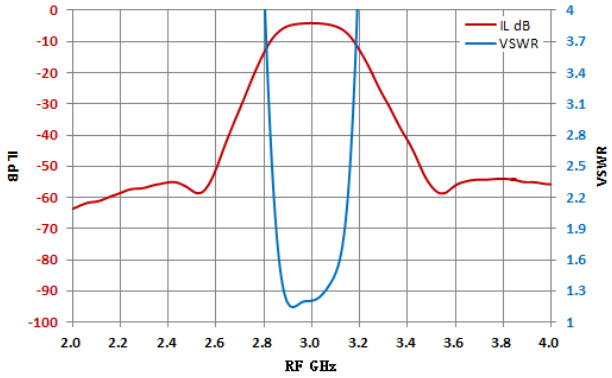
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.62mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

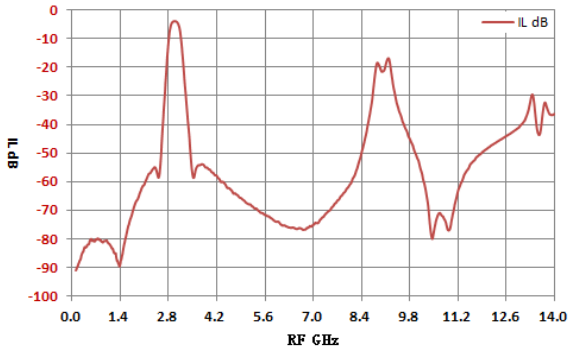
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



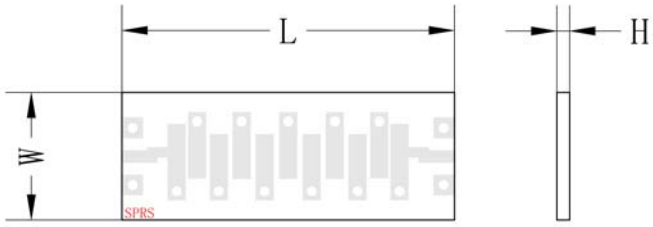
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	3.0	GHz
工作带宽	0	GHz
中心损耗	4.8	dB
带内波动	0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0	ns
带外抑制	30@DC-2.7GHz	dBc
带外抑制	30@3.3GHz	dBc

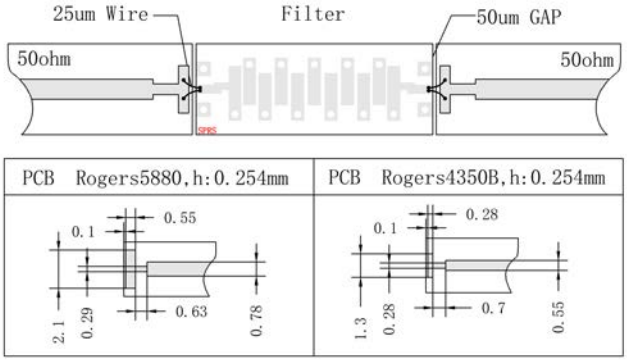
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：6.0，h：0.39

外形图：端口居中



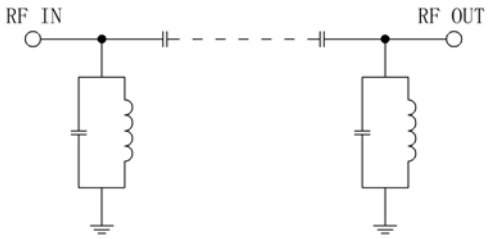
推荐装配图



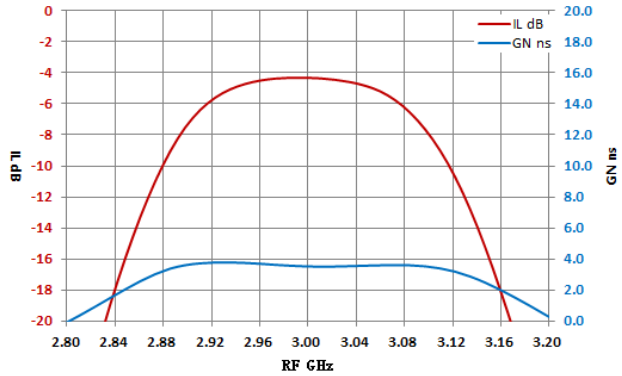
注意事项

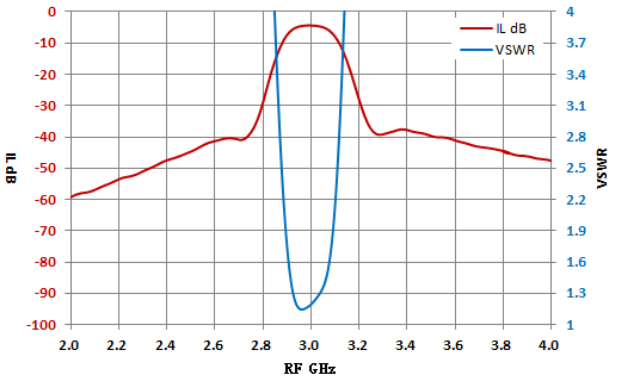
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.62mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

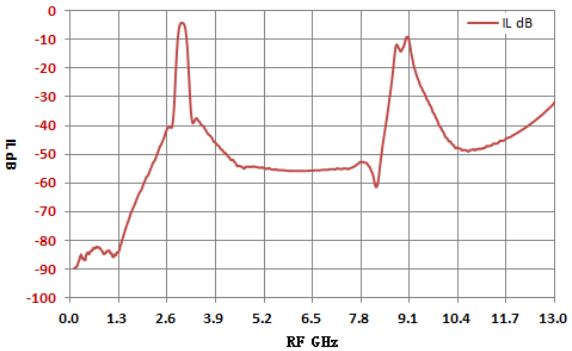
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



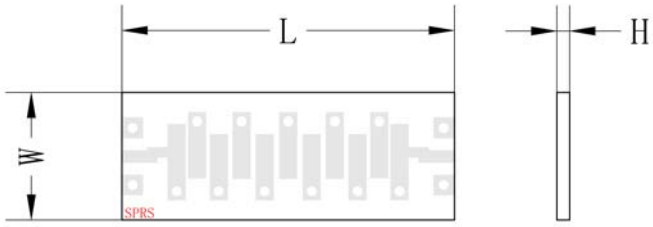
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	3.0	GHz
工作带宽	0	GHz
中心损耗	4.4	dB
带内波动	0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0	ns
带外抑制	40@DC-2.45GHz	dBc
带外抑制	40@3.6-8.0GHz	dBc

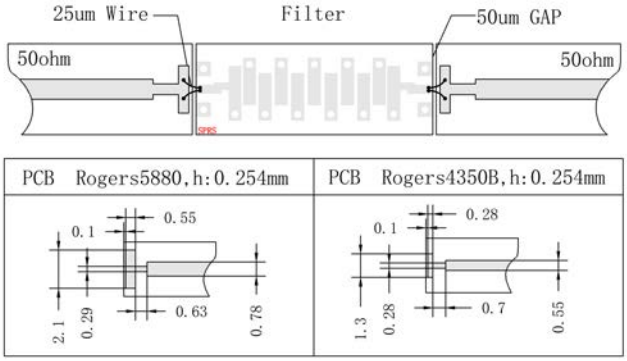
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：5.5，W：5.3，h：0.26

外形图：端口居中



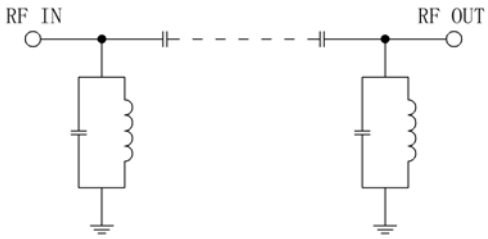
推荐装配图



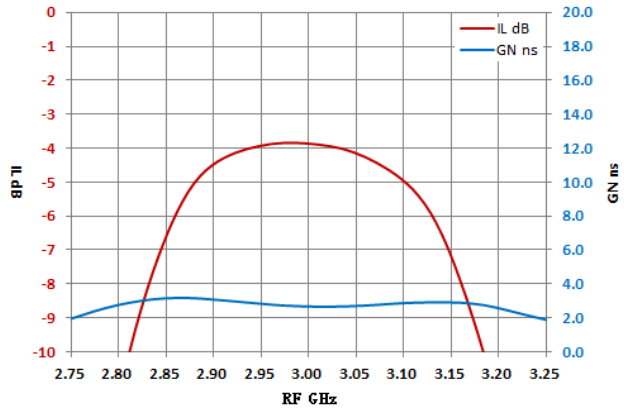
注意事项

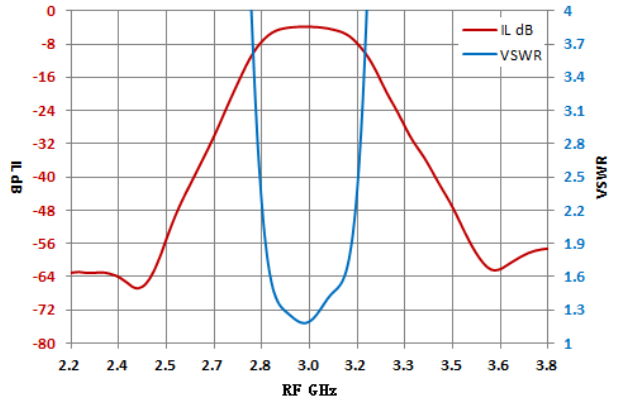
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

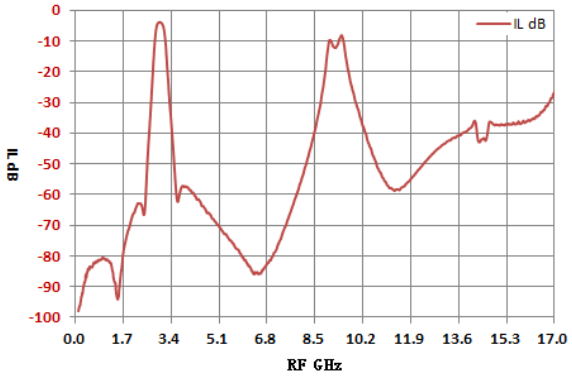
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

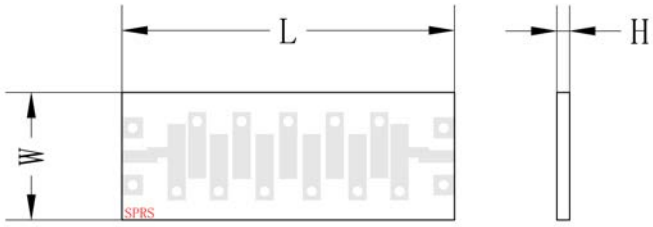
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	3.4	GHz
工作带宽	3.0-3.8	GHz
中心损耗	2.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-1.9GHz	dBc
带外抑制	40@5.1-8.0GHz	dBc

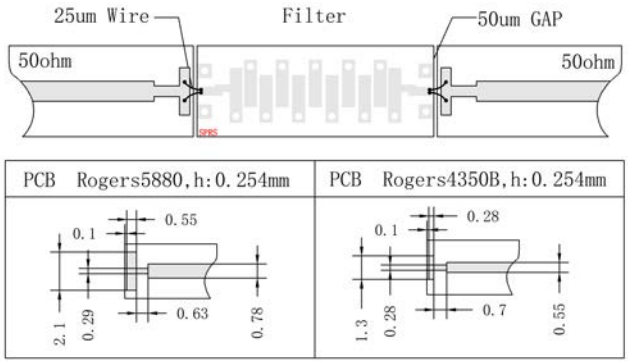
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：5.5，W：8.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



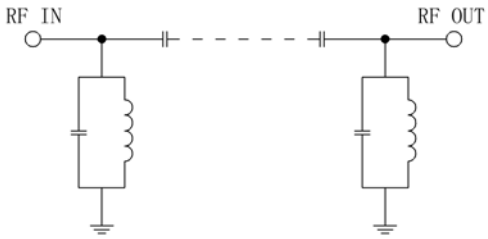
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

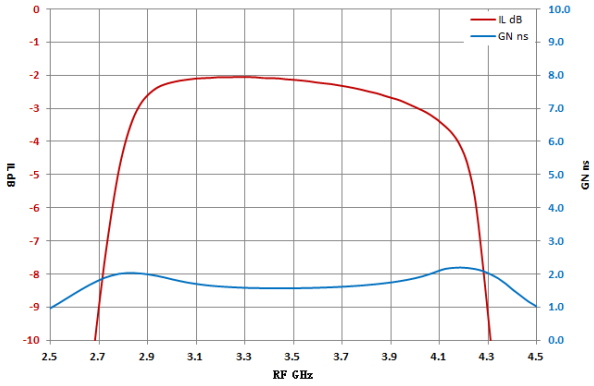
参考实物图

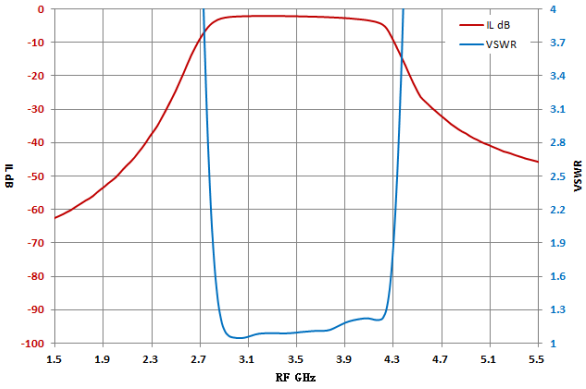


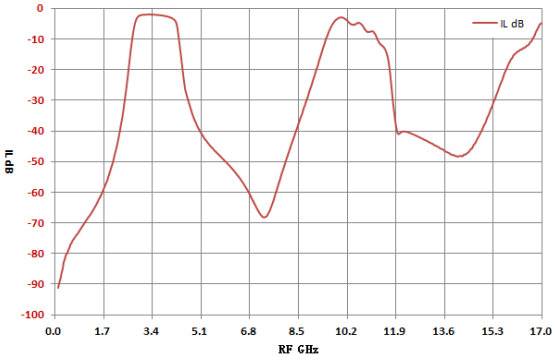
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

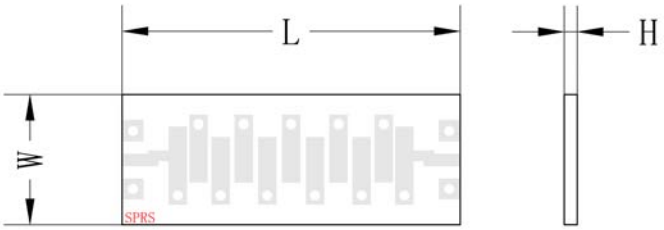
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	3.25	GHz
工作带宽	3.05-3.45	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	1.0	ns
带外抑制	40@DC-2.5GHz	dBc
带外抑制	50@4.1-7.0GHz	dBc

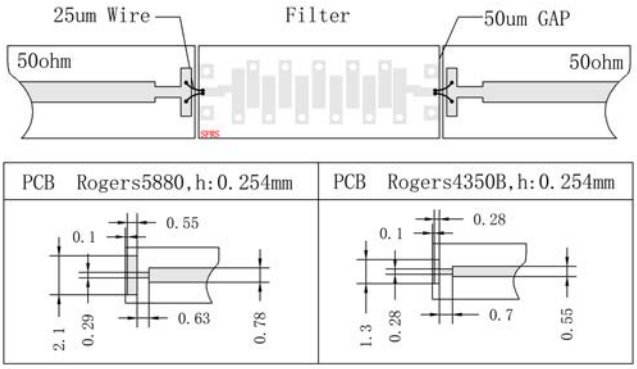
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：8.5，W：5.5，h：0.39

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.61mm,端口可互换;

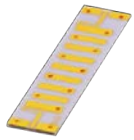
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

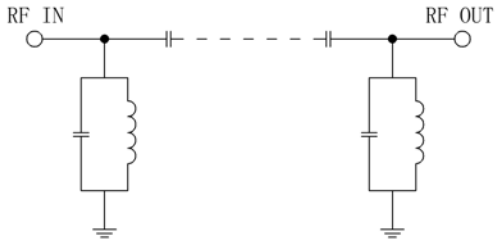
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

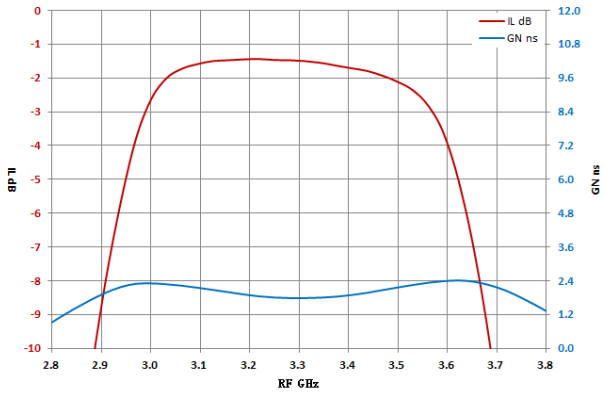
参考图

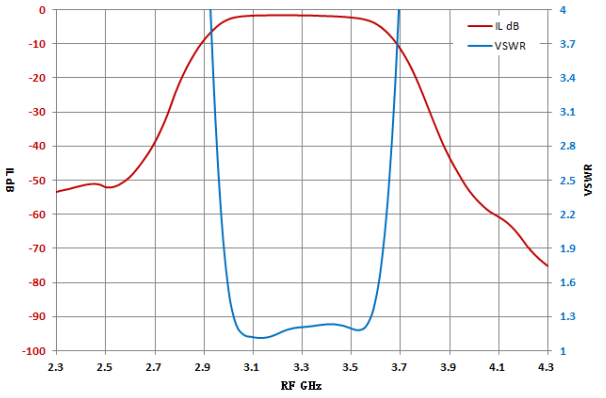


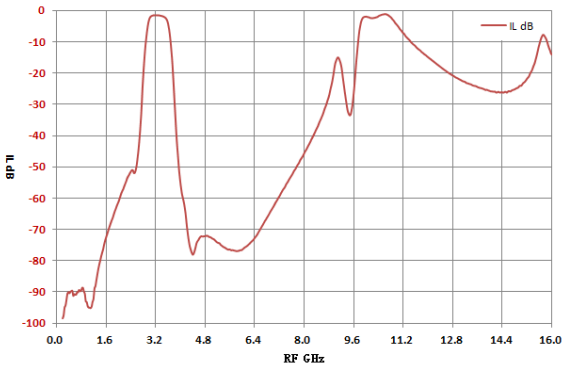
原理图



典型曲线







产品特点

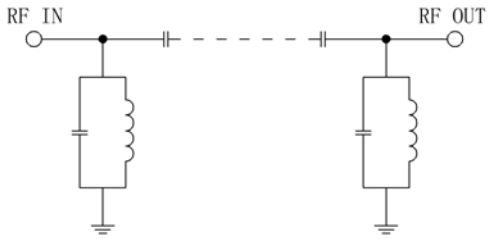
高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



技术要求

项目	参数	单位
中心频率	3.1	GHz
工作带宽	0	GHz
中心损耗	4.7	dB
带内波动	0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0	ns
带外抑制	40@DC-2.6GHz	dBc
带外抑制	40@3.7-8.0GHz	dBc

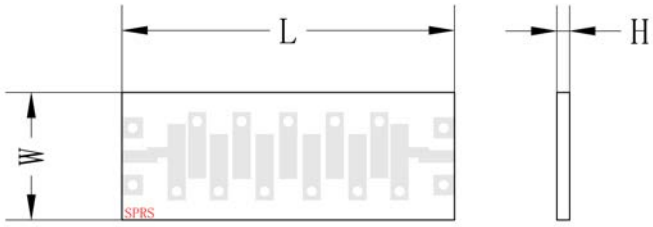
原理图



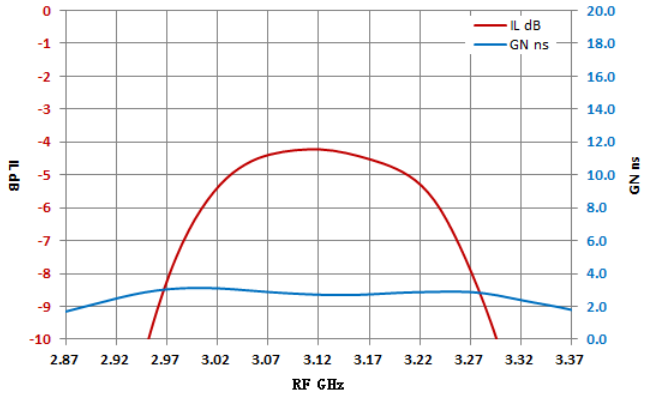
其它要求：设计保证

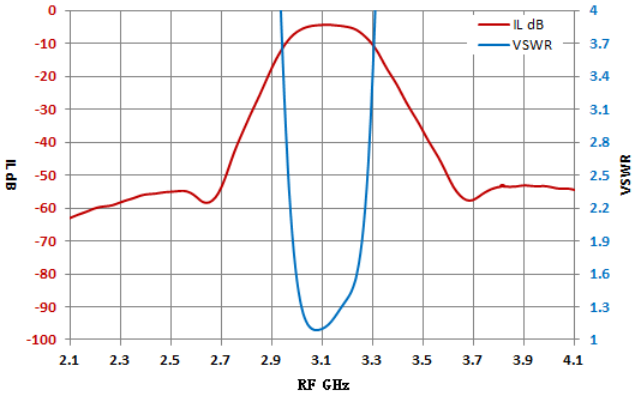
承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：6.0，h：0.39

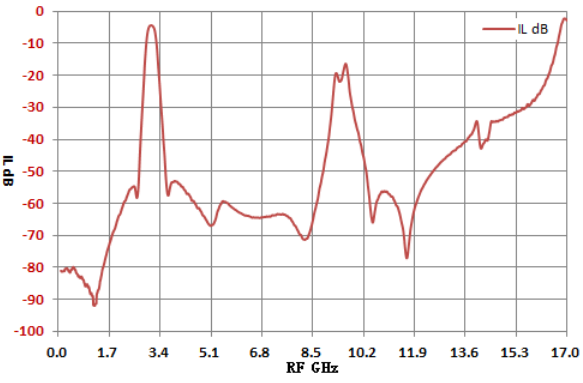
外形图：端口居中



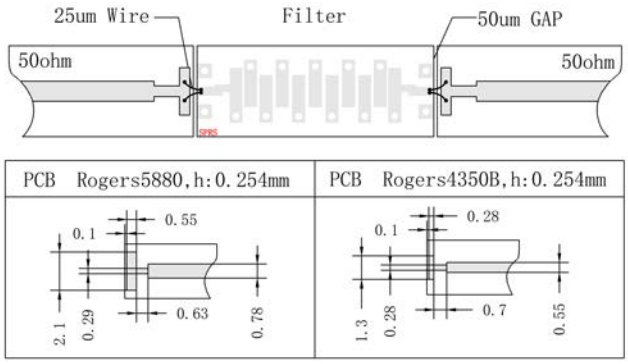
典型曲线







推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.62mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



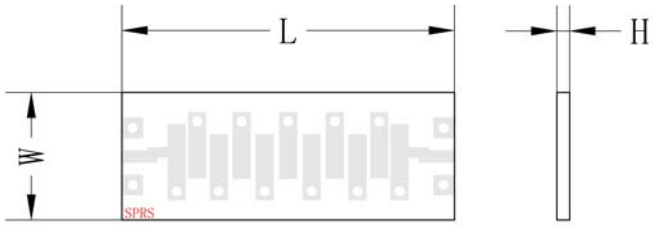
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	3.5	GHz
工作带宽	3.1-3.9	GHz
中心损耗	3.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	35@DC-2.5GHz	dBc
带外抑制	35@4.7-7.5GHz	dBc

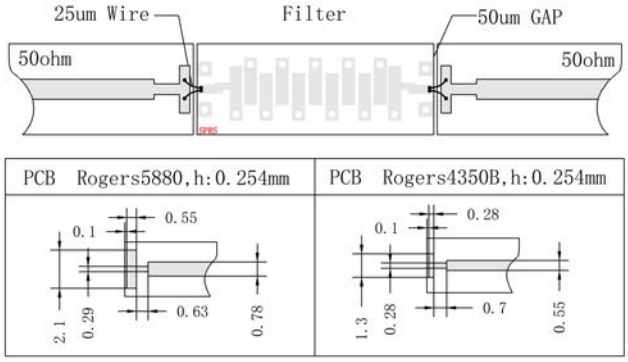
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：8.5，h：0.26

外形图：端口居中



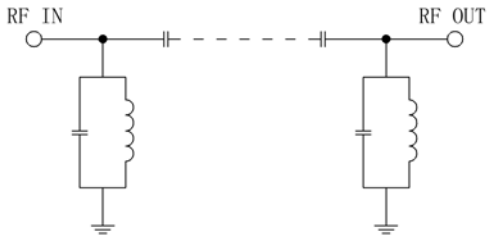
推荐装配图



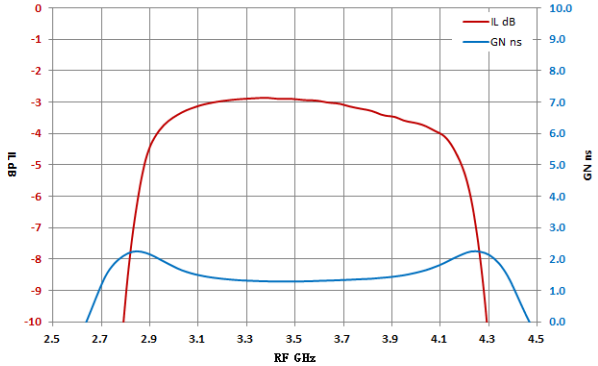
注意事项

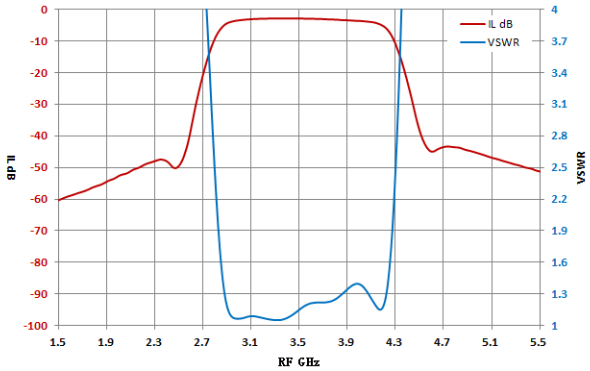
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

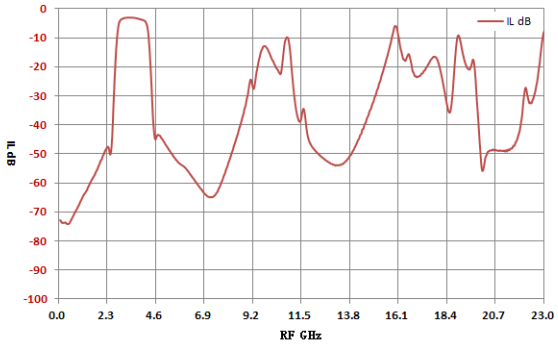
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



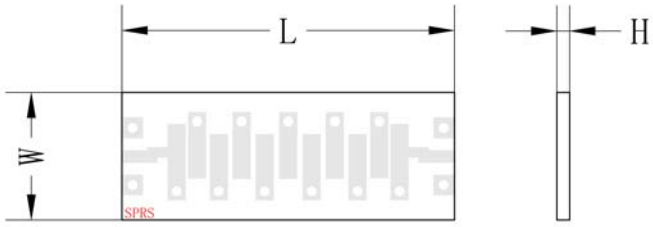
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	3.9	GHz
工作带宽	3.1-4.7	GHz
中心损耗	2.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.7	ns
带外抑制	30@DC-2.6GHz	dBc
带外抑制	30@5.6-9.0GHz	dBc

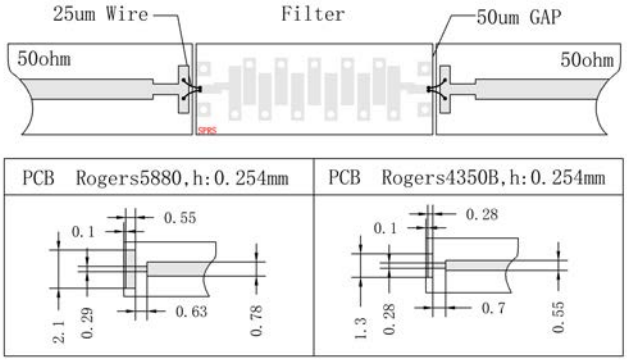
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：7.5，h：0.39

外形图：端口居中



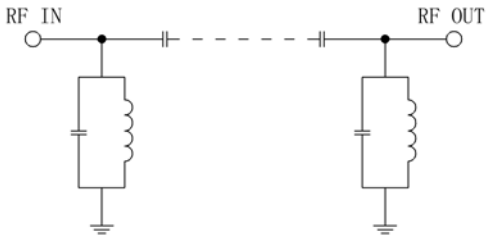
推荐装配图



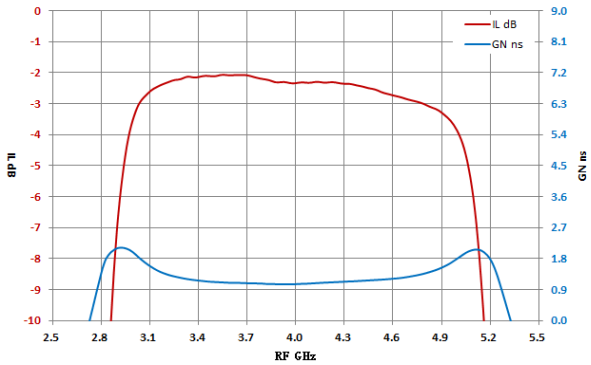
注意事项

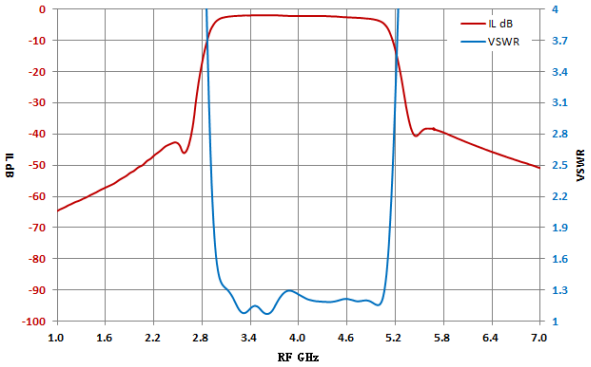
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

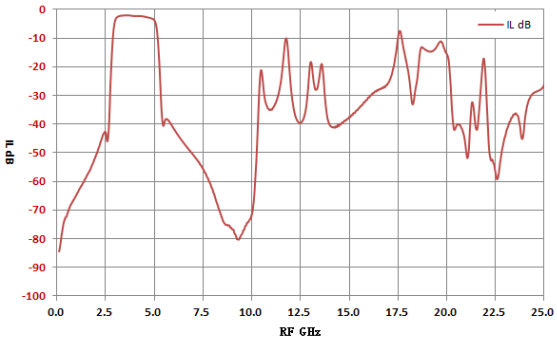
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

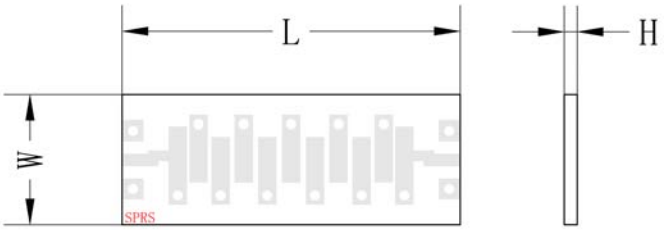
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	3.5	GHz
工作带宽	3.3-3.7	GHz
中心损耗	4.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	35@DC-2.7GHz	dBc
带外抑制	35@4.3-8.0GHz	dBc

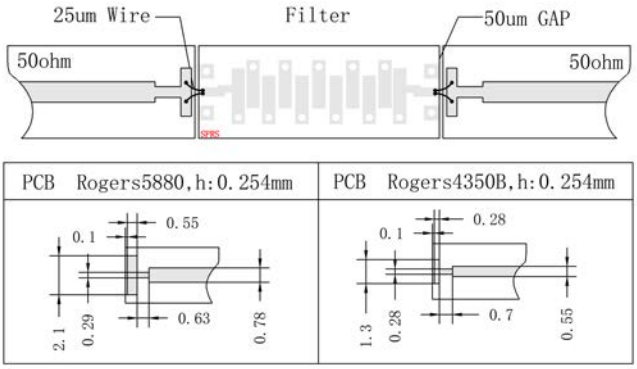
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：7.0，W：8.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

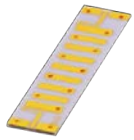
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

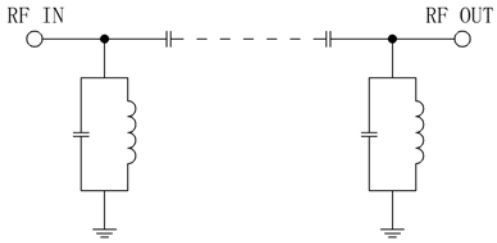
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度偏差个别产品会有调试胶补偿;

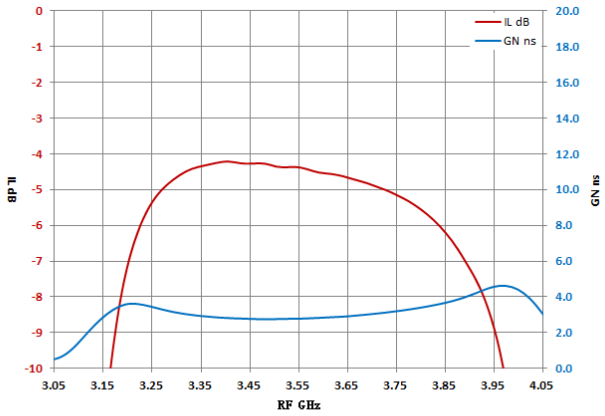
参考图

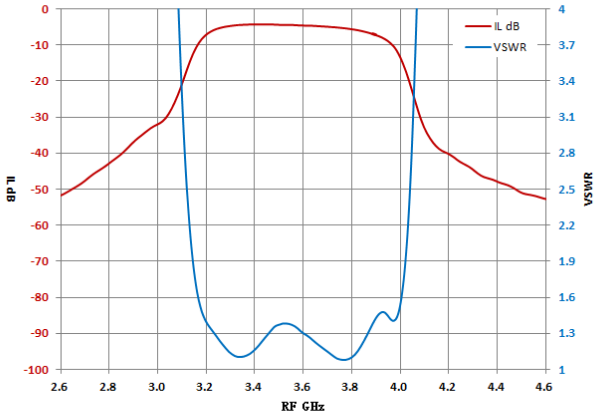


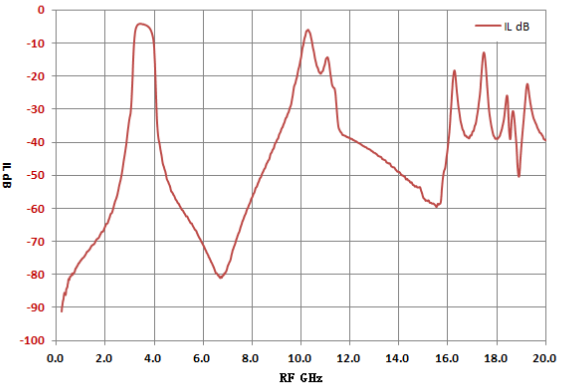
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



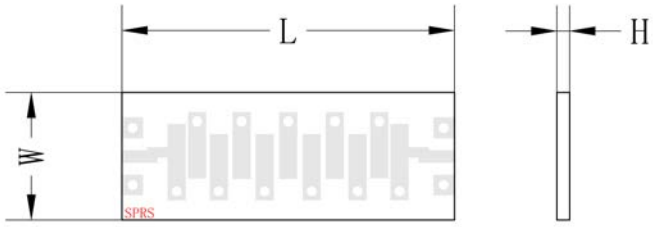
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	3.7	GHz
工作带宽	3.3-4.0	GHz
中心损耗	3.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-2.55GHz	dBc
带外抑制	40@4.8-8.0GHz	dBc

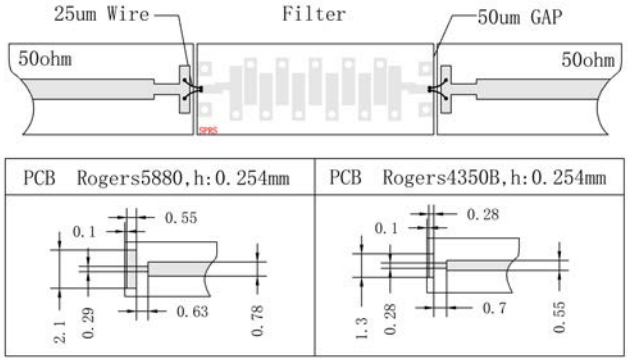
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：10.0，W：5.5，h：0.26

外形图：端口居中



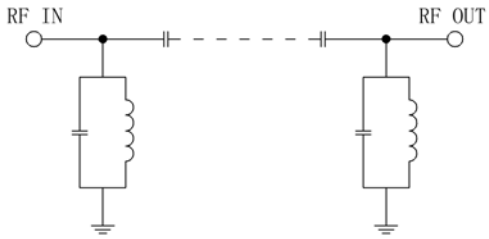
推荐装配图



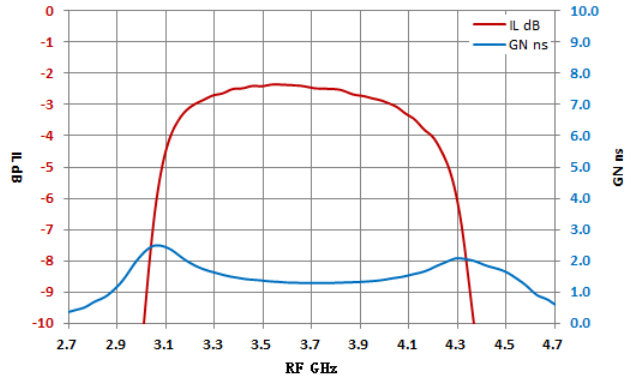
注意事项

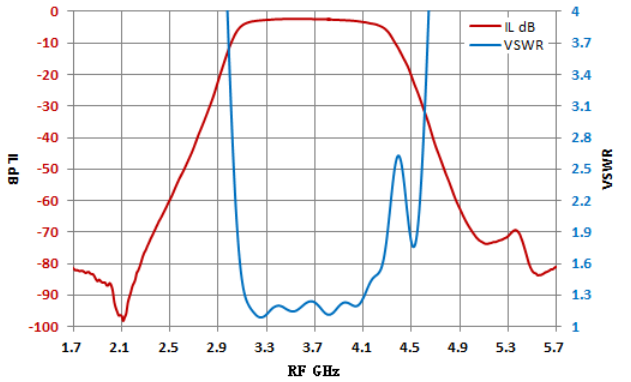
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

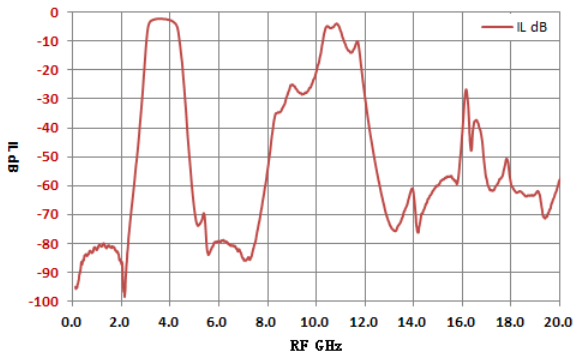
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

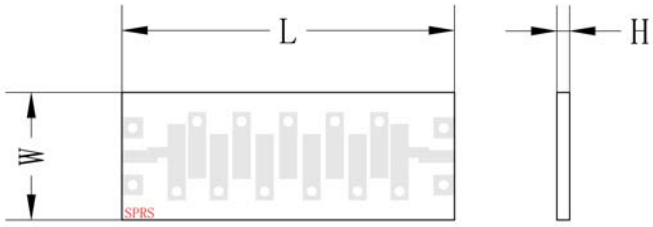
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	3.95	GHz
工作带宽	3.3-4.6	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-2.6GHz	dBc
带外抑制	40@5.4-10.0GHz	dBc

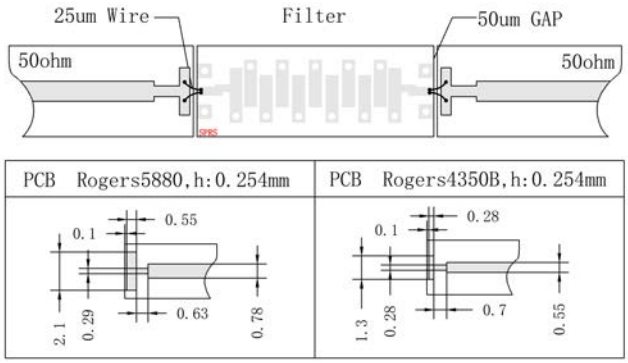
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：6.0，h：0.39

外形图：端口居中



推荐装配图



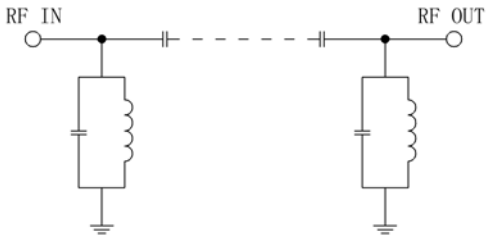
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.61mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

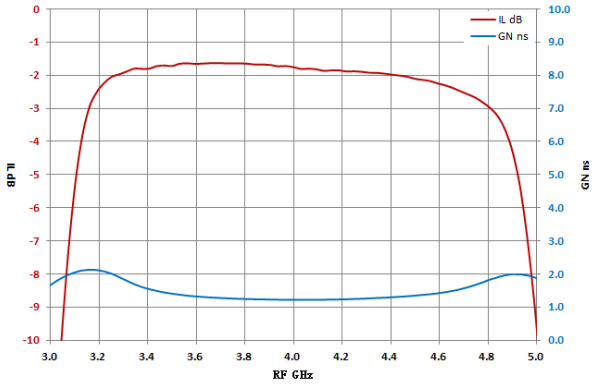
参考实物图

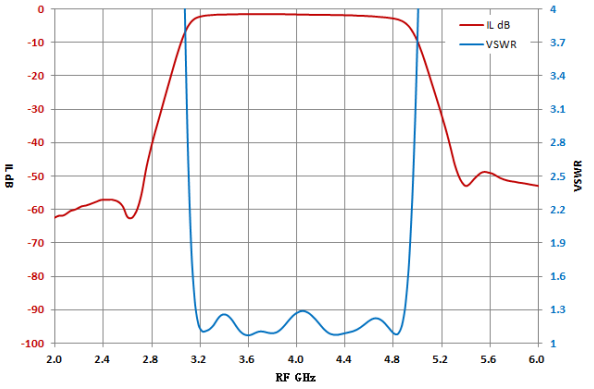


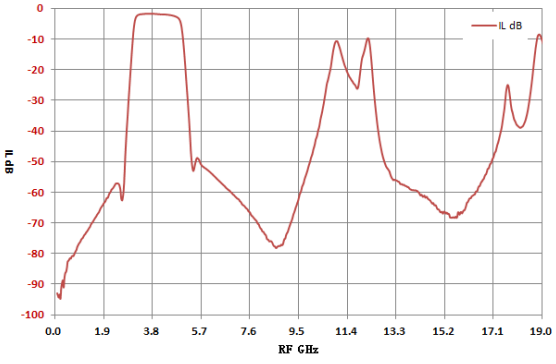
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

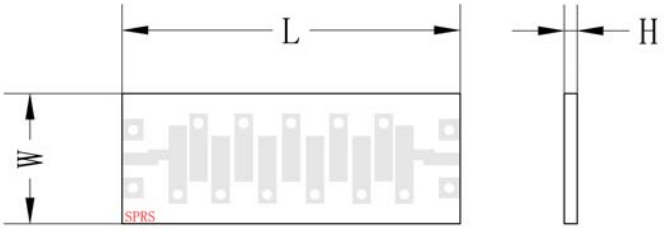
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	3.35	GHz
中心损耗	6.0	dB
驻波比	1.7:1	
带外抑制	40@DC-2.8GHz	dBc
带外抑制	40@3.9-8.0GHz	dBc

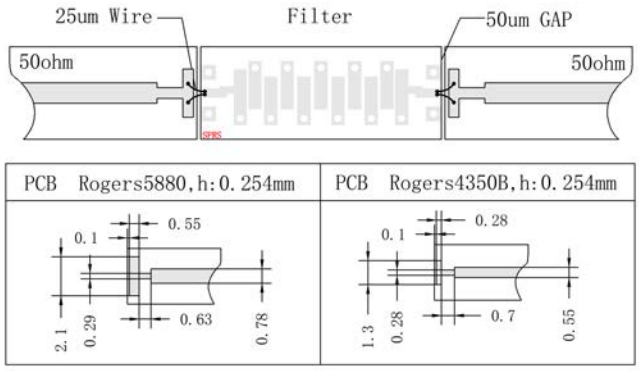
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：6.5，W：6.0，h：0.39

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.61mm,端口可互换;

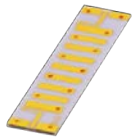
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

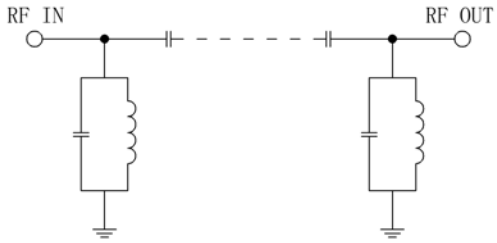
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

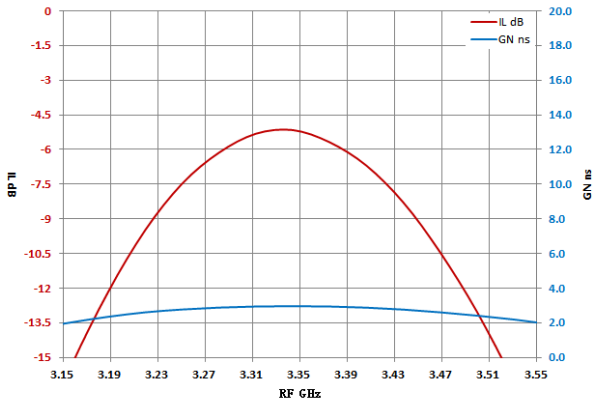
参考图

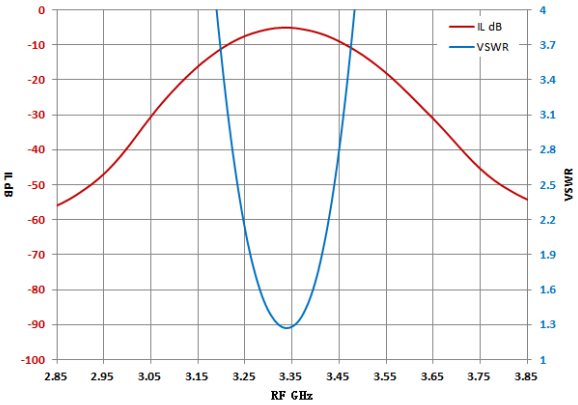


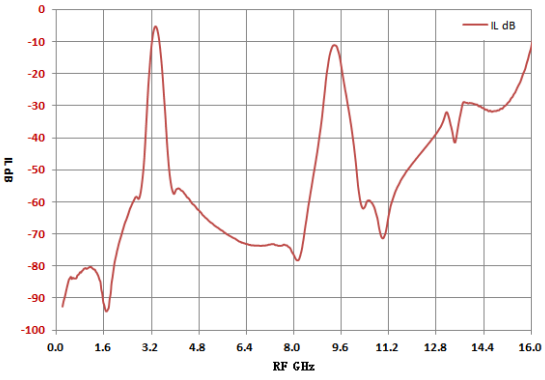
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



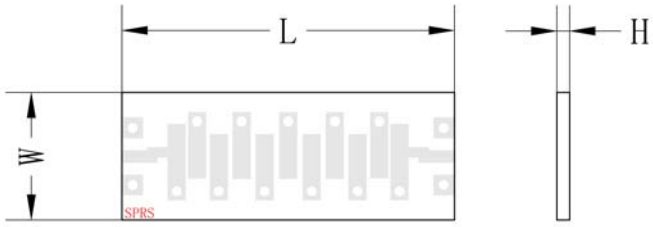
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	3.45	GHz
工作带宽	3.4-3.5	GHz
中心损耗	4.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.6	ns
带外抑制	40@DC-3.0GHz	dBc
带外抑制	40@4.1-8.0GHz	dBc

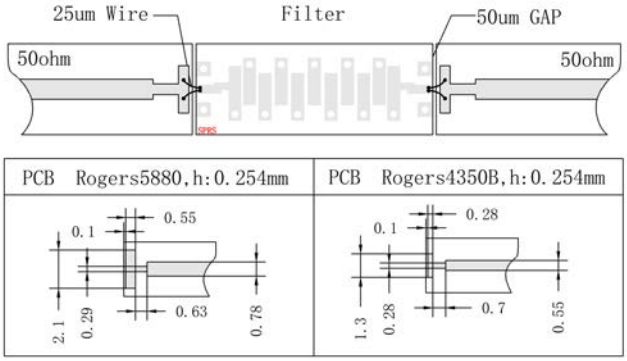
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：6.0，h：0.39

外形图：端口居中



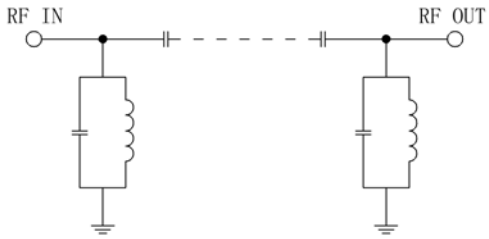
推荐装配图



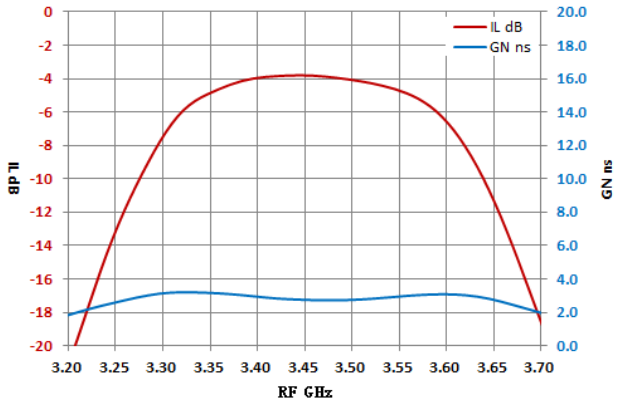
注意事项

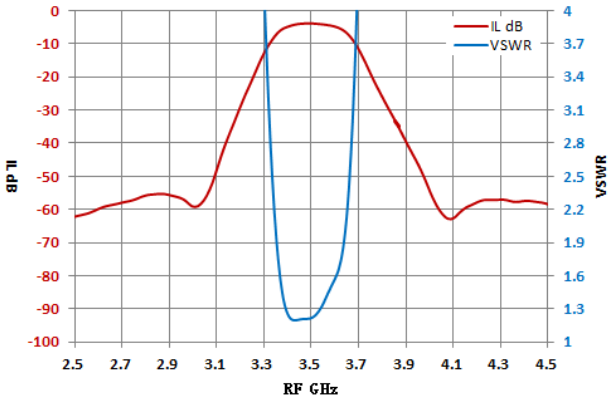
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.62mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

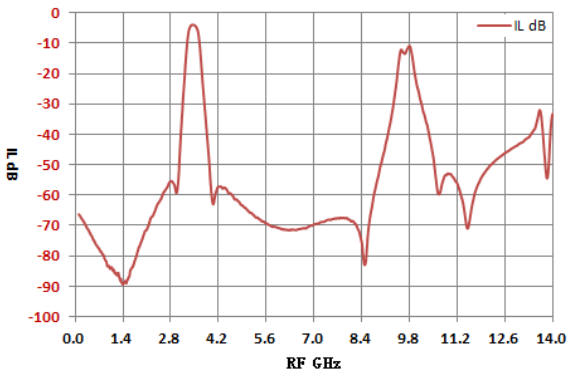
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

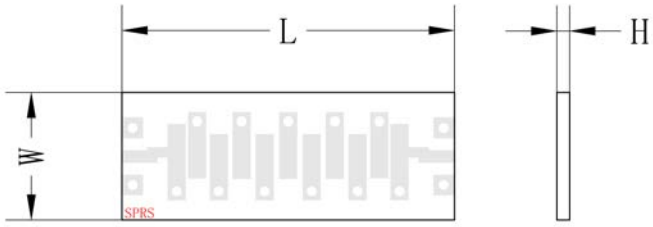
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	4.0	GHz
工作带宽	3.4-4.6	GHz
中心损耗	2.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	1.0	ns
带外抑制	40@DC-2.5GHz	dBc
带外抑制	40@5.3-9.0GHz	dBc

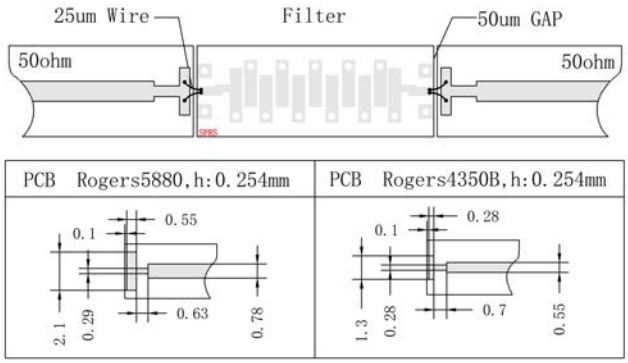
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：6.0，h：0.39

外形图：端口居中



推荐装配图



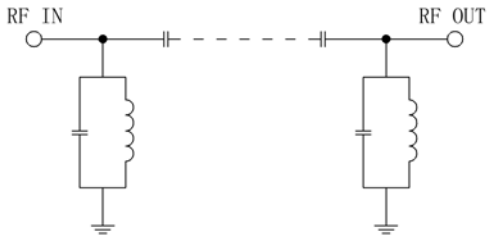
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

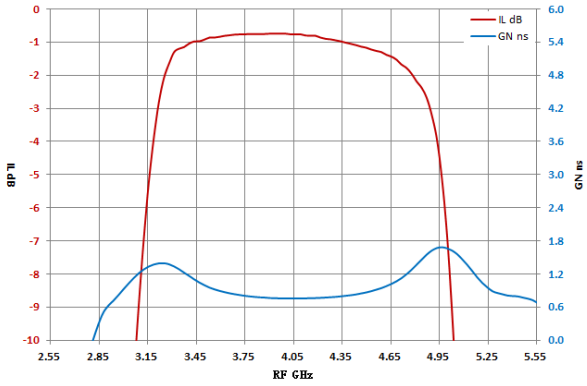
参考实物图

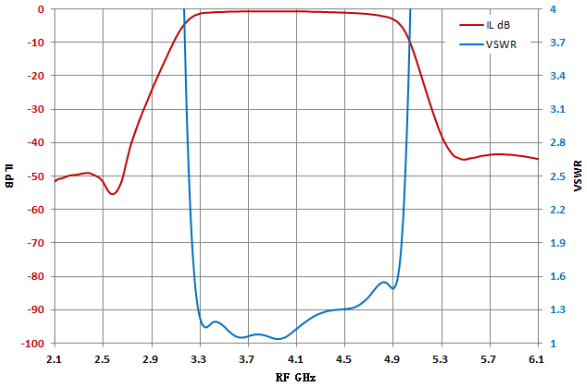


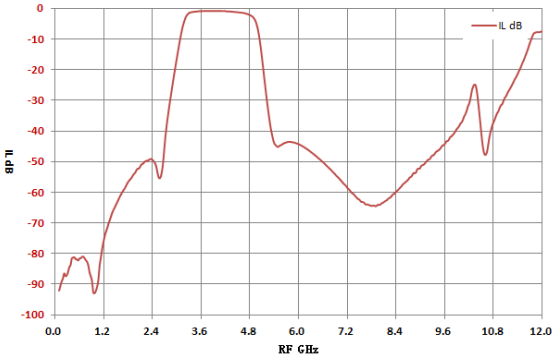
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

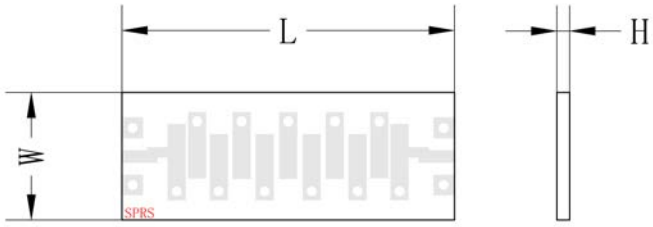
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	4.0	GHz
工作带宽	3.5-4.5	GHz
中心损耗	2.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.7	ns
带外抑制	40@DC-2.5GHz	dBc
带外抑制	40@5.5-10.0GHz	dBc

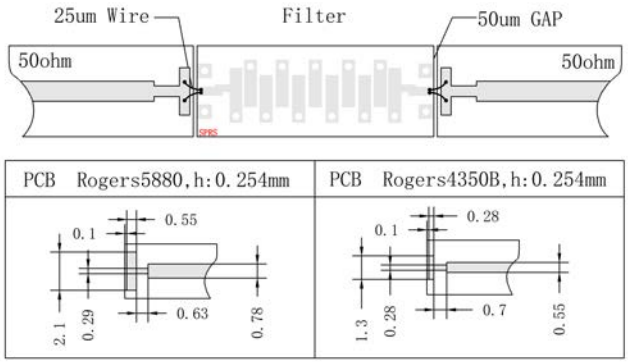
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：6.0，h：0.39

外形图：端口居中



推荐装配图



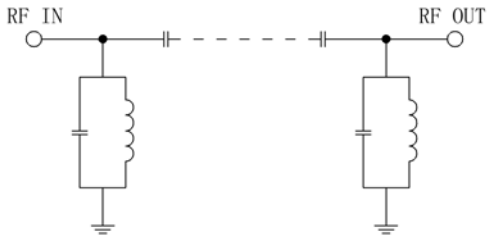
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.61mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

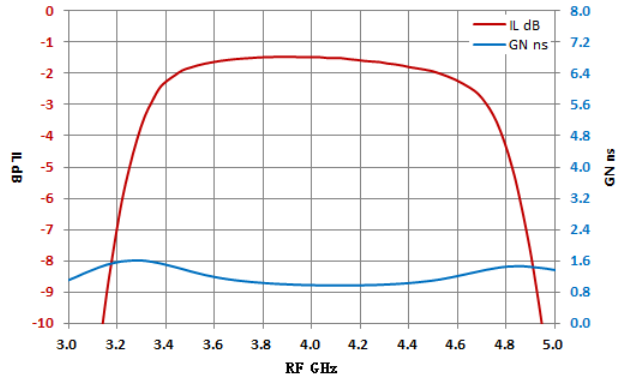
参考实物图

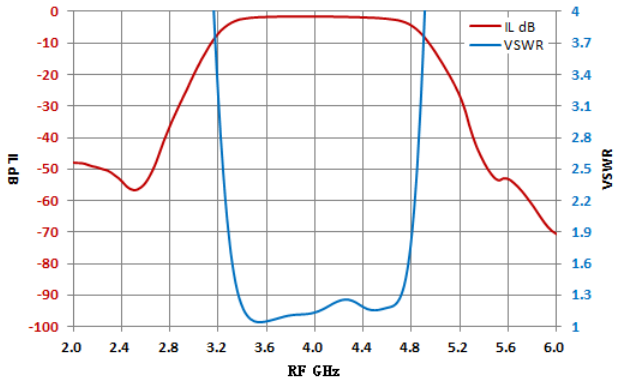


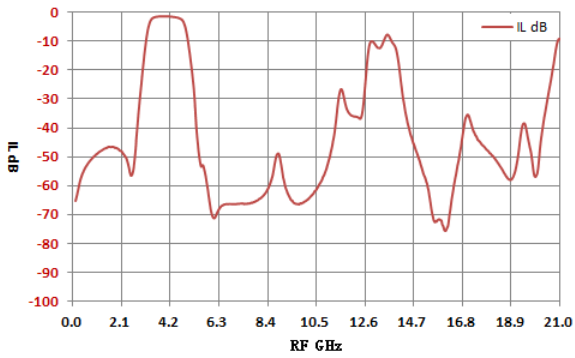
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

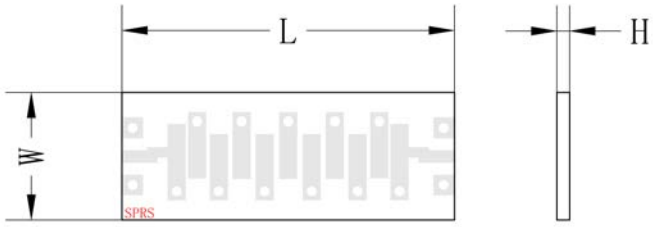
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	4.2	GHz
工作带宽	3.5-4.9	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-2.5GHz	dBc
带外抑制	40@6.0-11.0GHz	dBc

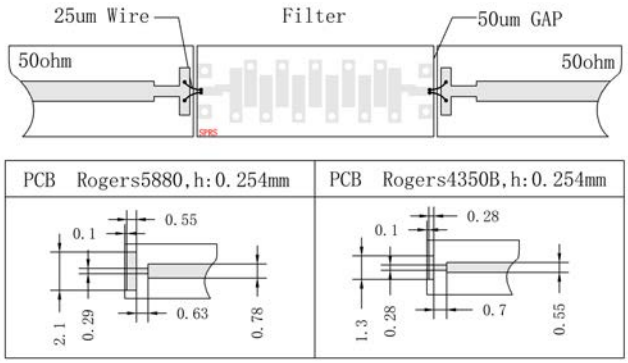
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：5.0，h：0.39

外形图：端口居中



推荐装配图



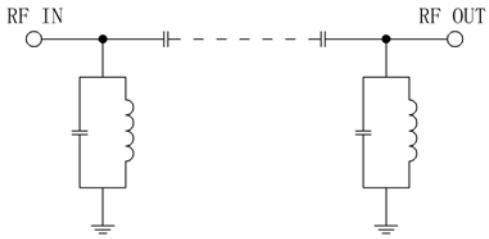
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.61mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

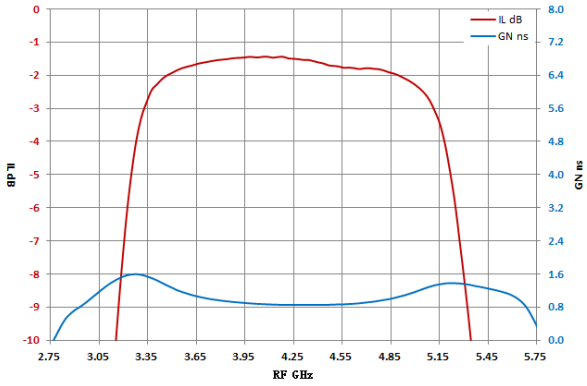
参考实物图

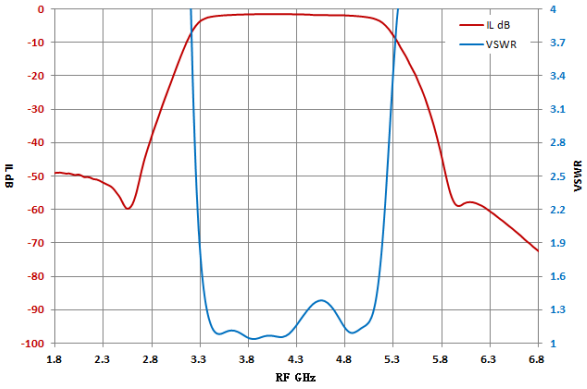


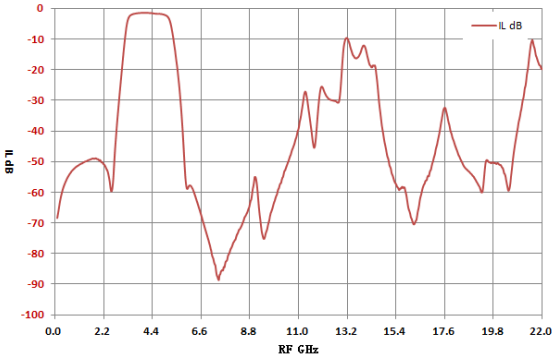
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



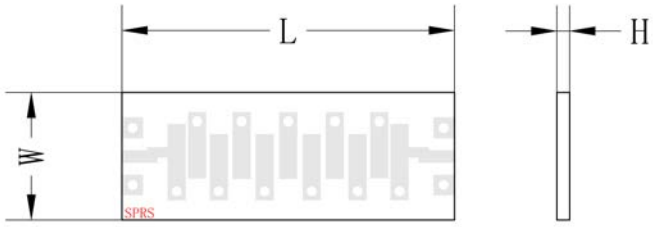
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	3.6	GHz
工作带宽	0	GHz
中心损耗	5.1	dB
带内波动	0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0	ns
带外抑制	40@DC-3.1GHz	dBc
带外抑制	40@4.2-8.0GHz	dBc

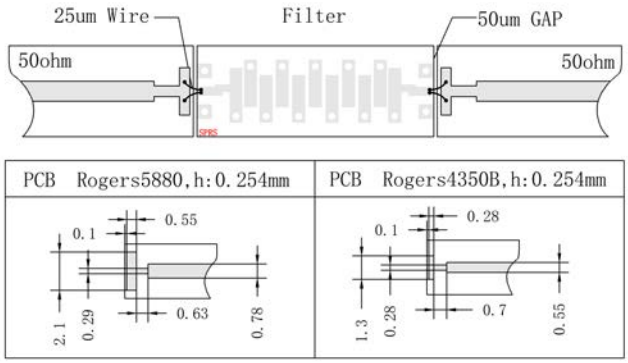
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：6.0，h：0.39

外形图：端口居中



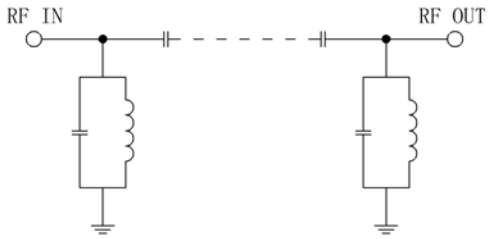
推荐装配图



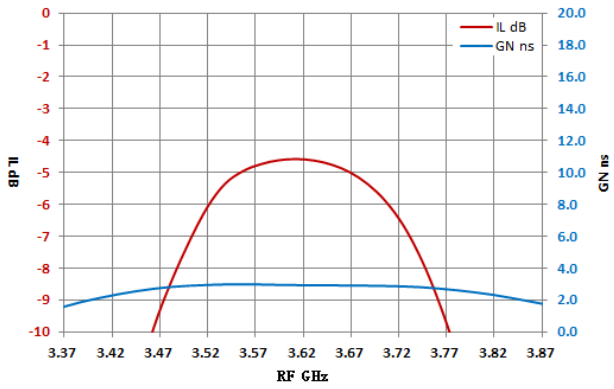
注意事项

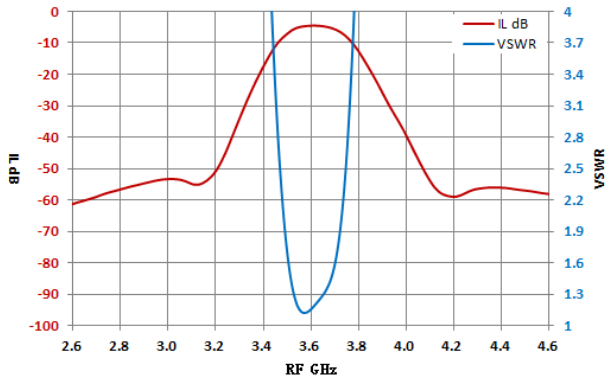
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.62mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

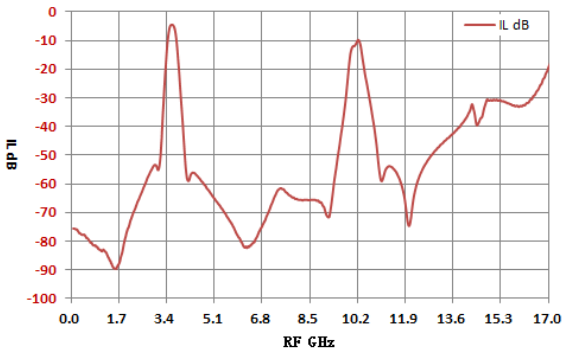
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



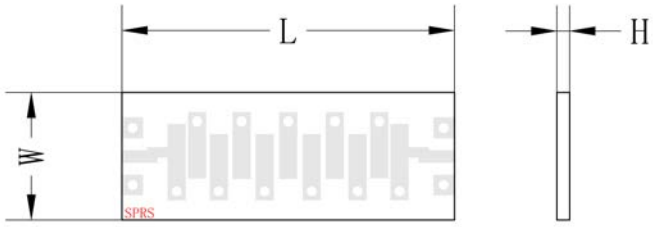
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	4.3	GHz
工作带宽	3.6-5.0	GHz
中心损耗	2.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.8	ns
带外抑制	40@DC-2.8GHz	dBc
带外抑制	40@6.1-10.0GHz	dBc

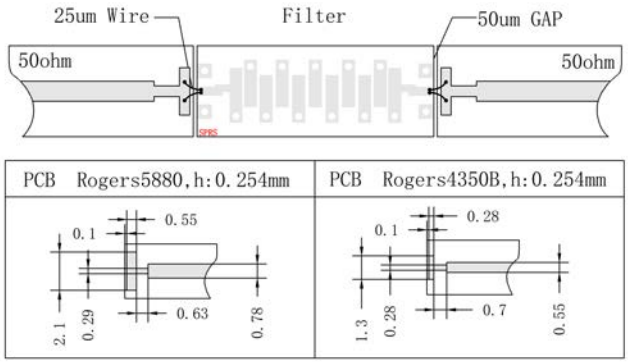
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：7.5，h：0.26

外形图：端口居中



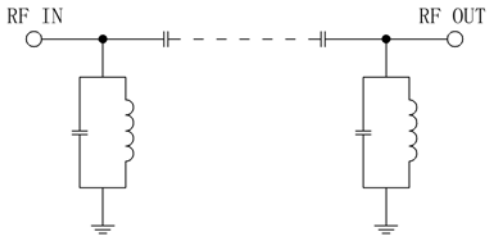
推荐装配图



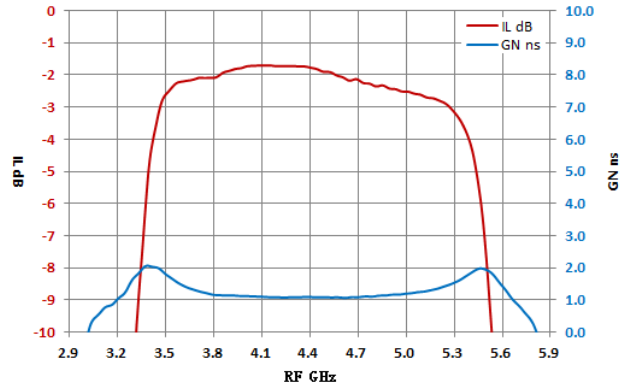
注意事项

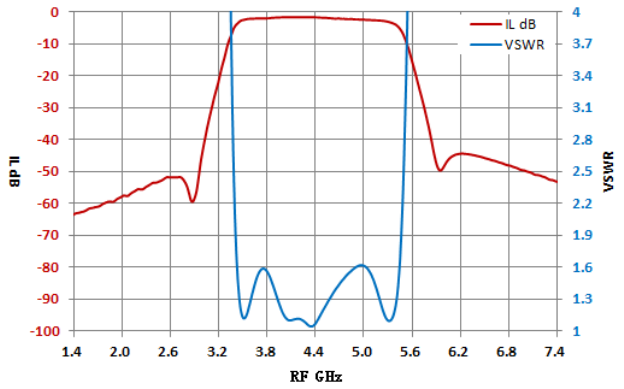
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

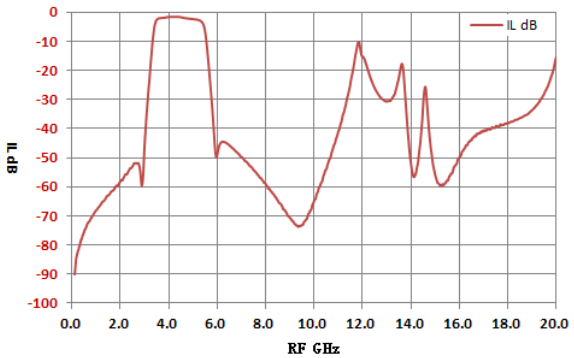
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



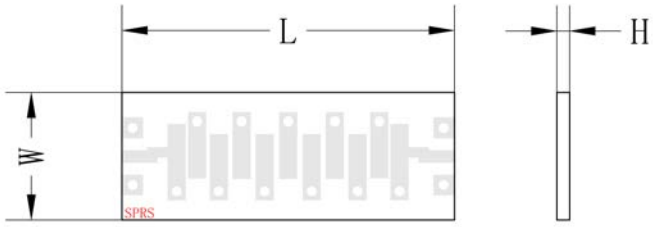
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	3.95	GHz
工作带宽	3.9-4.0	GHz
中心损耗	3.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-3.0GHz	dBc
带外抑制	40@5.0-9.0GHz	dBc

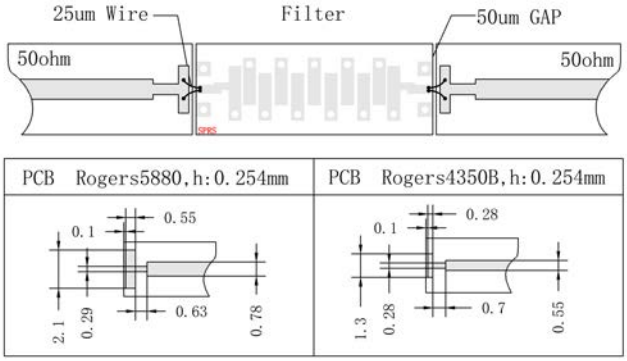
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：4.5，h：0.26

外形图：端口居中



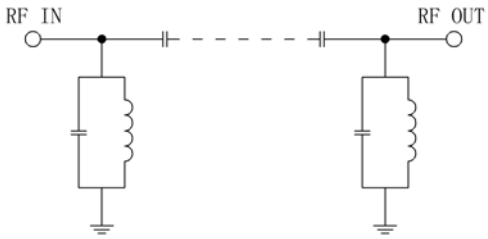
推荐装配图



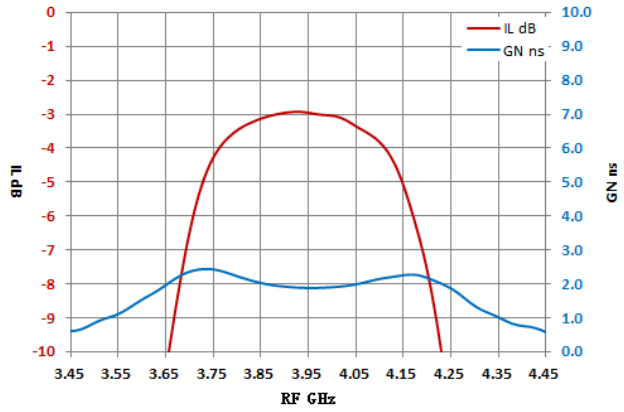
注意事项

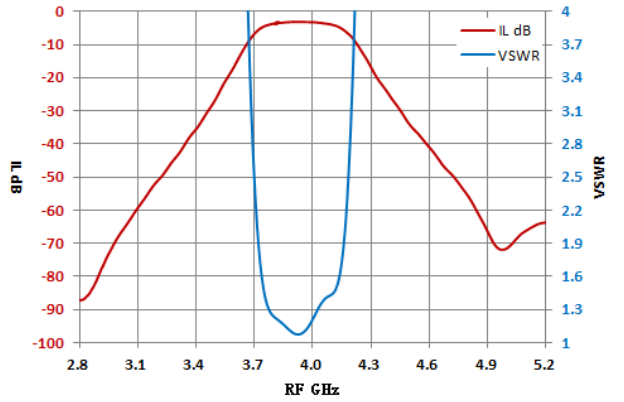
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

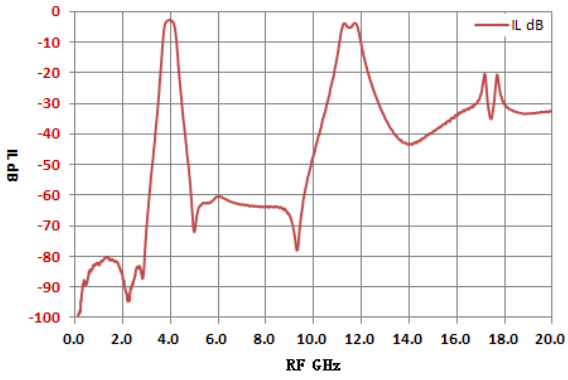
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



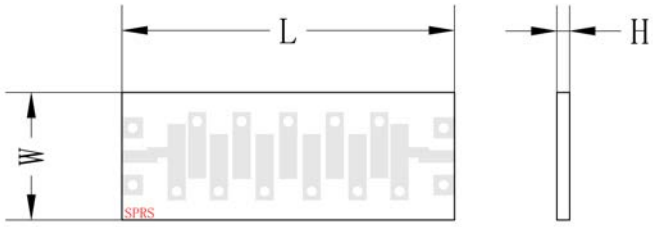
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	4.4	GHz
工作带宽	3.9-4.9	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-3.0GHz	dBc
带外抑制	40@5.9-9.0GHz	dBc

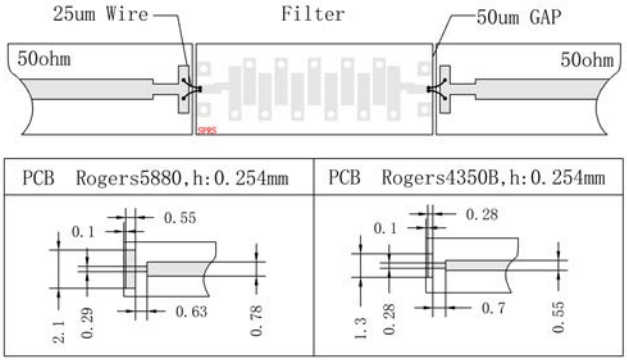
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：10.0，W：4.5，h：0.26

外形图：端口居中



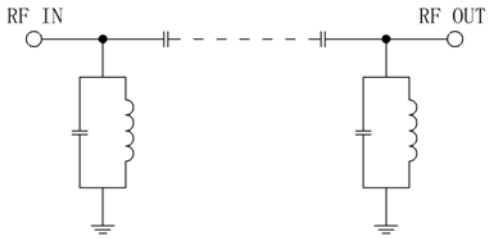
推荐装配图



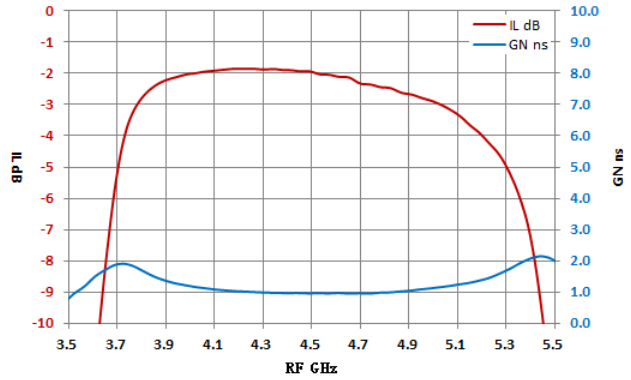
注意事项

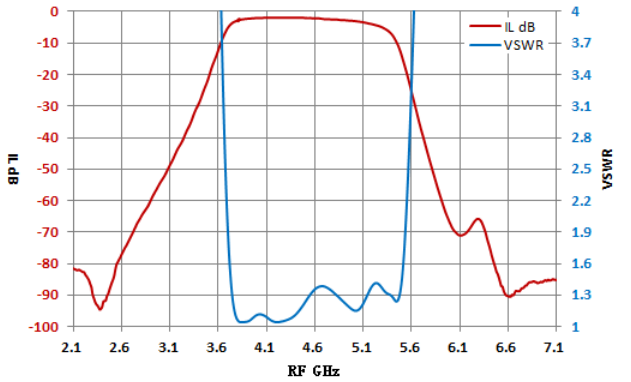
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

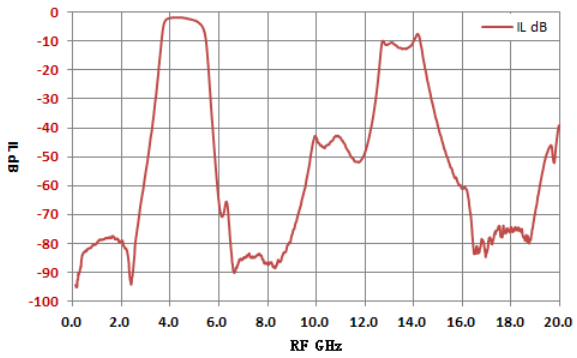
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

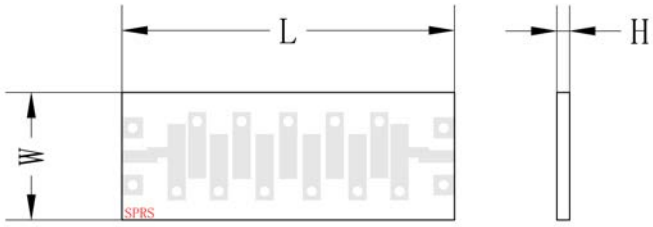
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	5.75	GHz
工作带宽	3.9-7.6	GHz
中心损耗	3.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-1.4GHz	dBc
带外抑制	40@9.0-15.0GHz	dBc

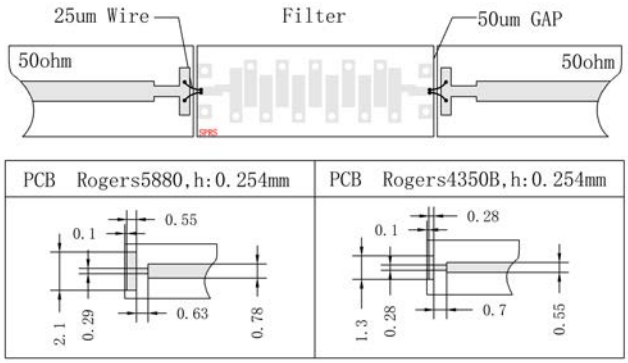
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：5.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



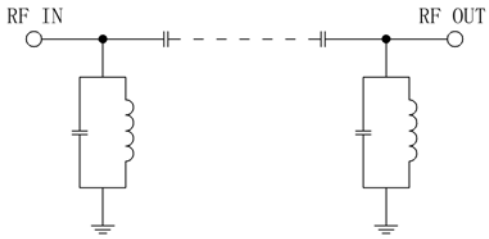
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

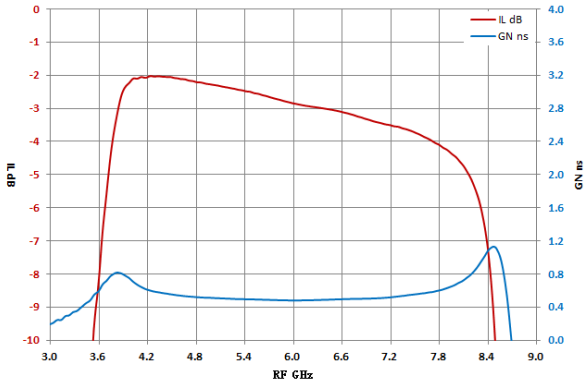
参考实物图

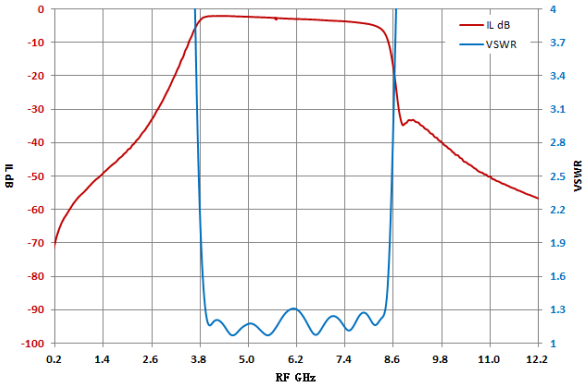


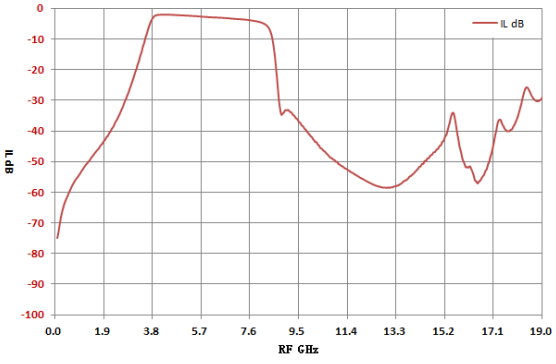
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



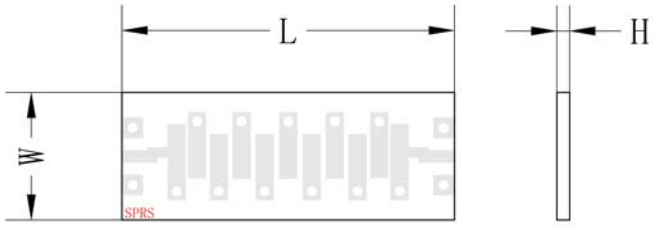
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	4.0	GHz
工作带宽	3.91-4.01	GHz
中心损耗	5.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-3.5GHz	dBc
带外抑制	40@4.6-9.0GHz	dBc

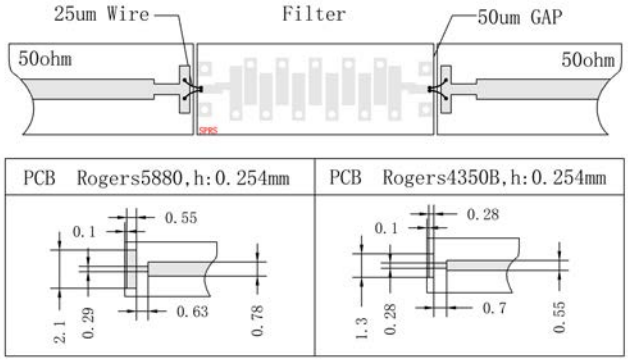
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：5.5，h：0.39

外形图：端口居中



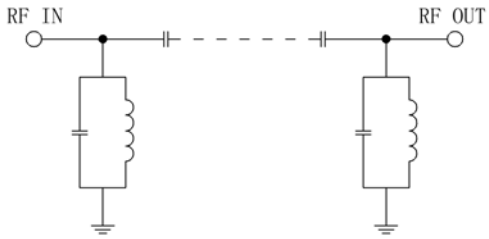
推荐装配图



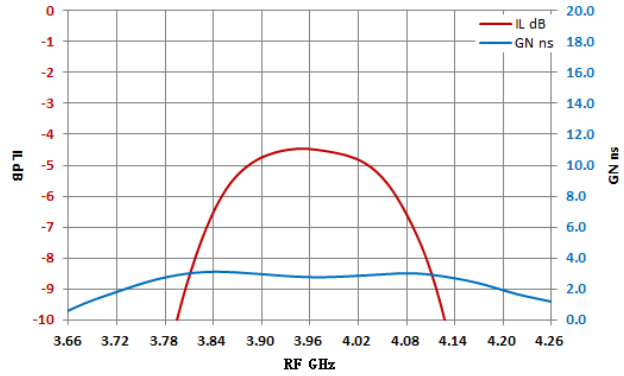
注意事项

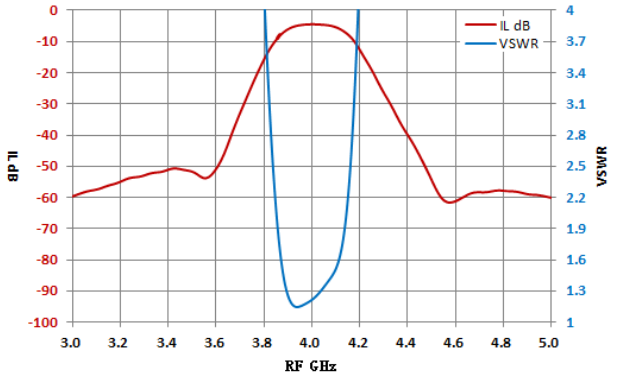
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.62mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

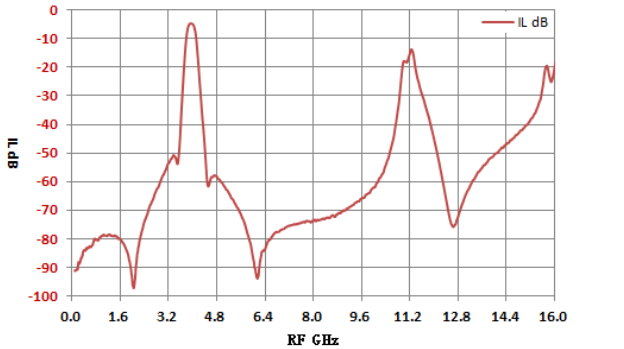
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

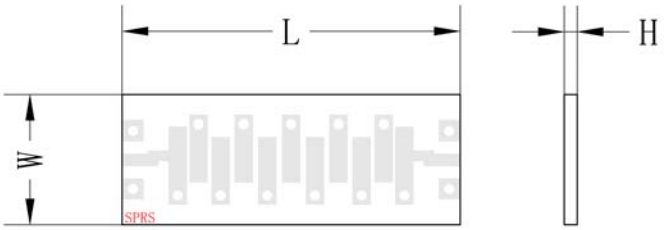
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	4.2	GHz
工作带宽	4.0-4.4	GHz
中心损耗	2.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	30@DC-3.4GHz	dBc
带外抑制	35@5.1-9.0GHz	dBc

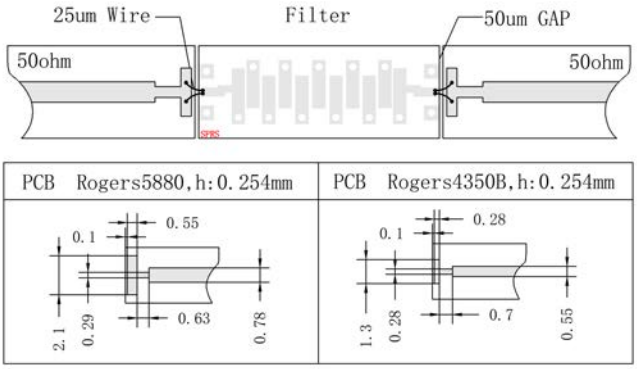
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：6.5，W：5.5，h：0.39

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.61mm,端口可互换;

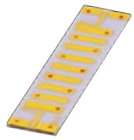
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

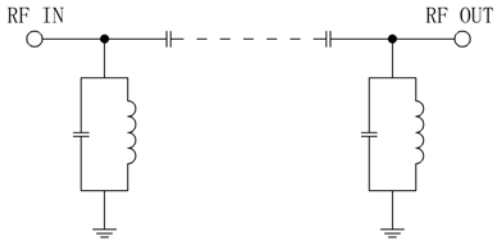
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

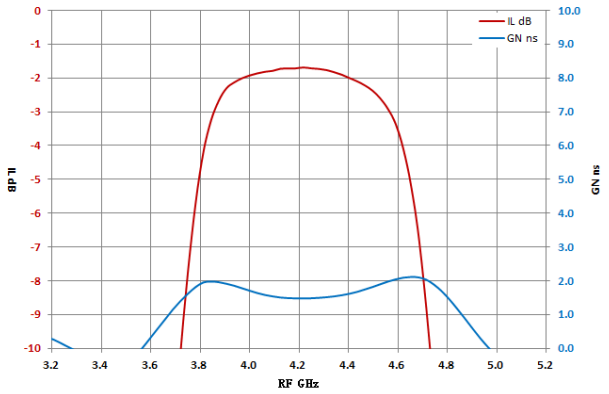
参考图

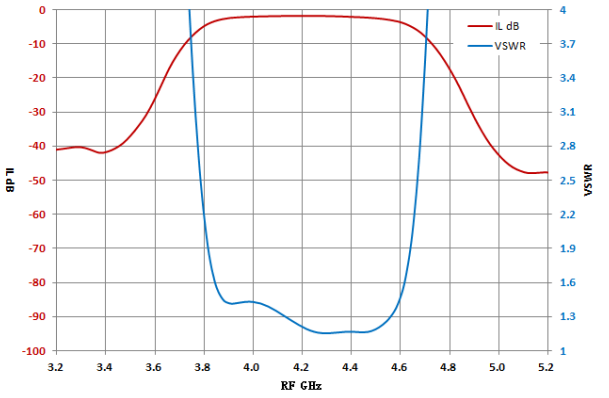


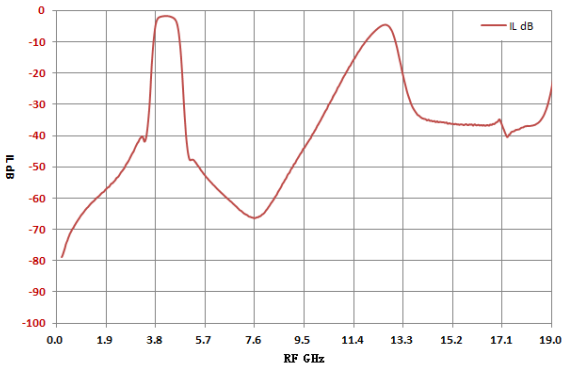
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



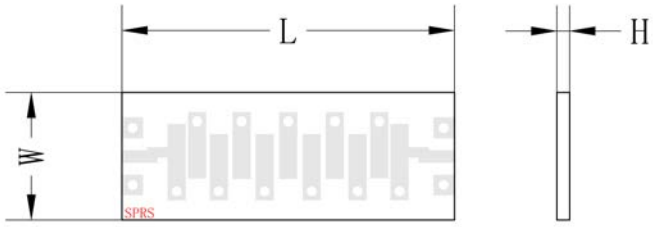
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	4.2	GHz
工作带宽	4.0-4.4	GHz
中心损耗	4.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	1.0	ns
带外抑制	30@DC-3.5GHz	dBc
带外抑制	40@5.5-10.0GHz	dBc

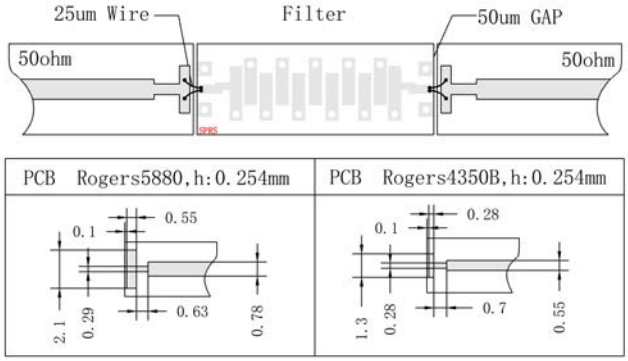
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：7.0，h：0.26

外形图：端口居中



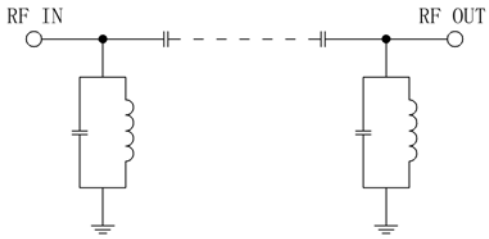
推荐装配图



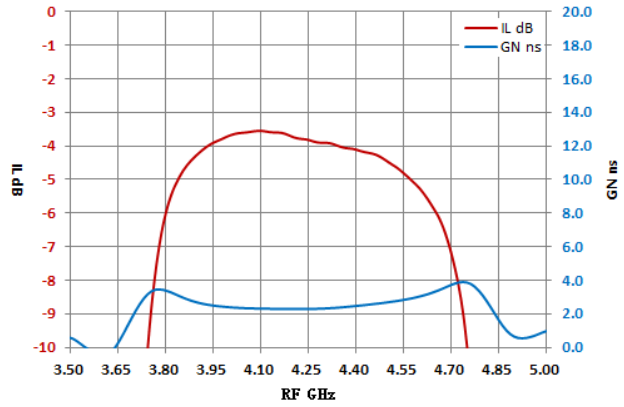
注意事项

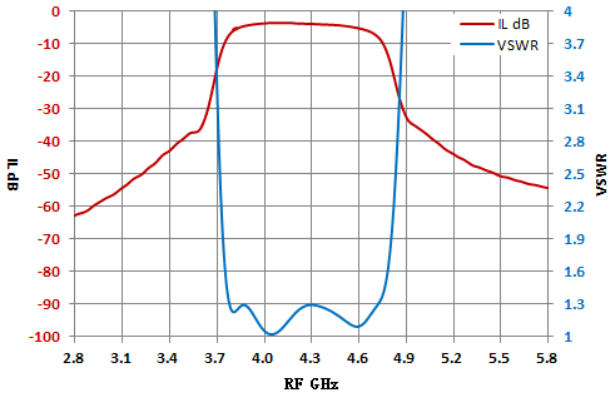
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

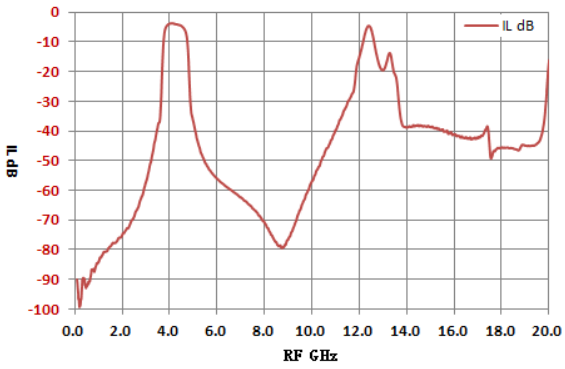
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

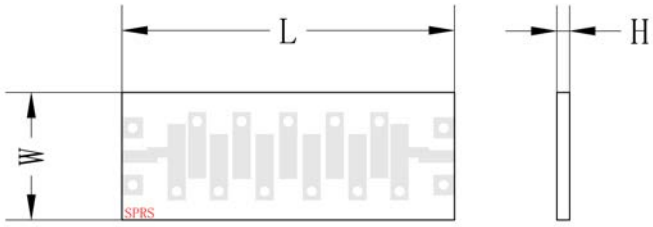
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	4.35	GHz
工作带宽	4.0-4.7	GHz
中心损耗	2.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-3.4GHz	dBc
带外抑制	40@5.4-9.0GHz	dBc

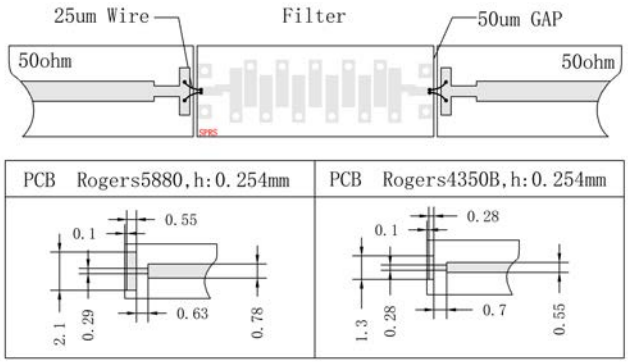
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.5，W：5.2，h：0.39

外形图：端口居中



推荐装配图



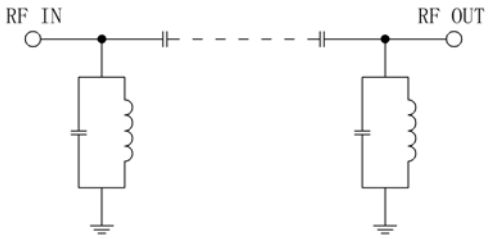
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.61mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

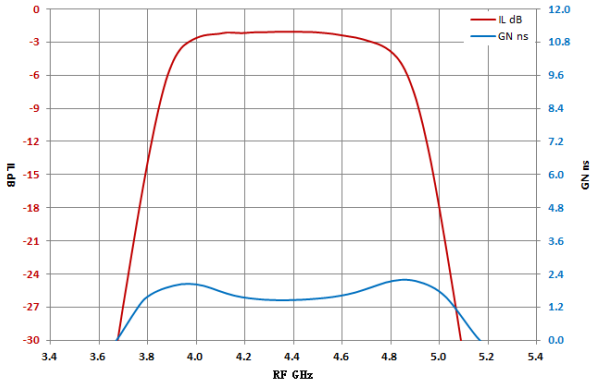
参考实物图

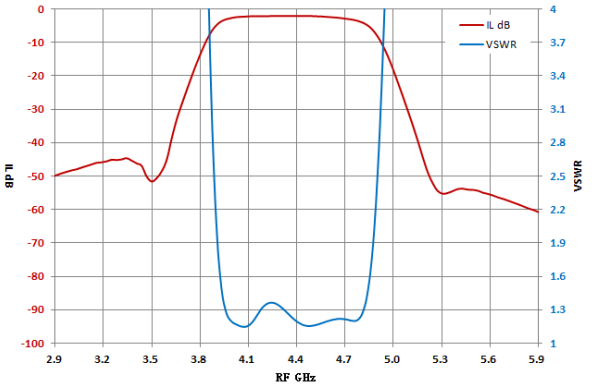


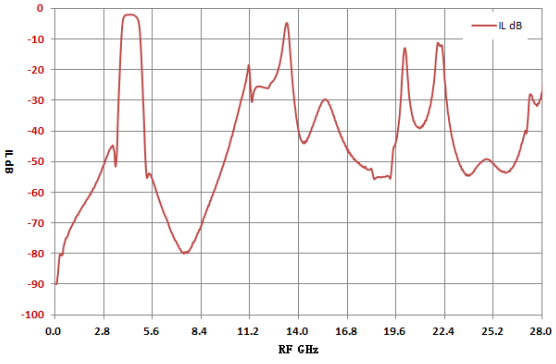
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



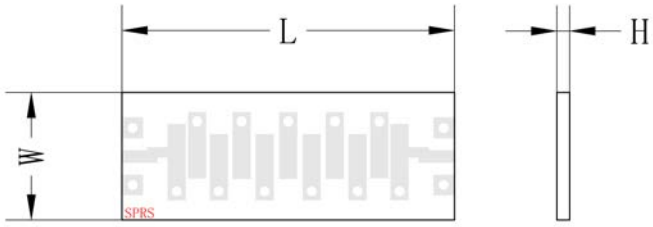
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	4.5	GHz
工作带宽	4.0-5.0	GHz
中心损耗	3.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	35@DC-3.3GHz	dBc
带外抑制	35@5.8-10.0GHz	dBc

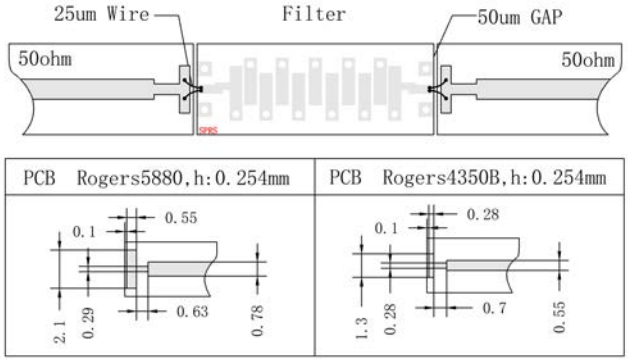
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：7.0，h：0.26

外形图：端口居中



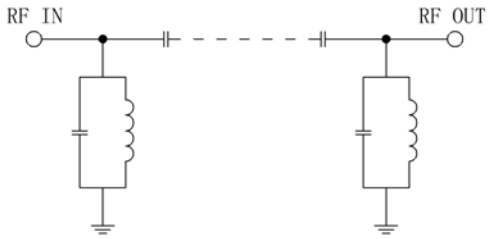
推荐装配图



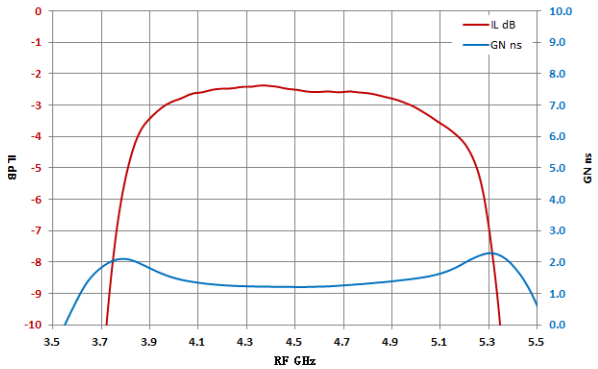
注意事项

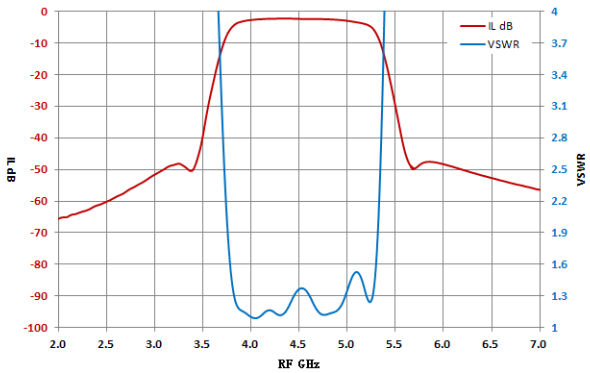
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

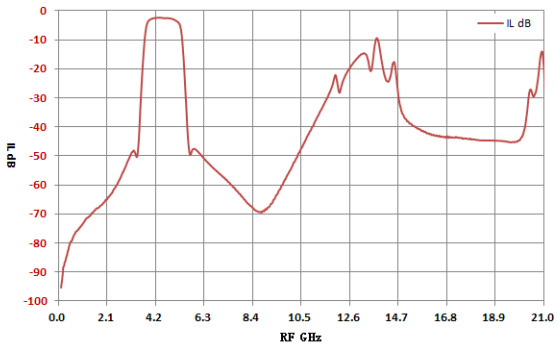
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



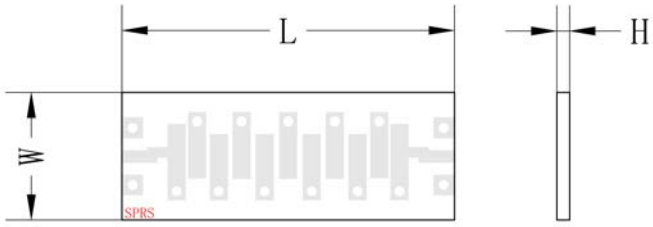
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	5.0	GHz
工作带宽	4.0-6.0	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-2.0GHz	dBc
带外抑制	30@7.2-11.5GHz	dBc

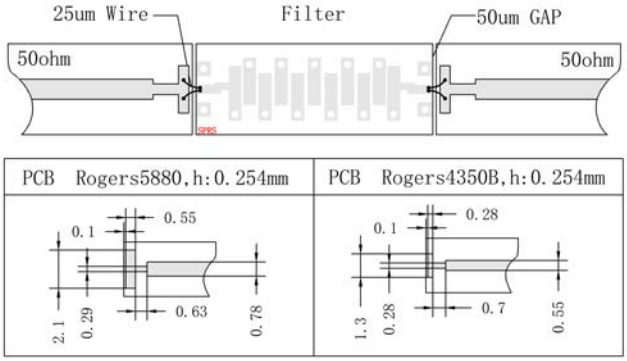
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：5.5，W：6.5，h：0.26

外形图：端口居中



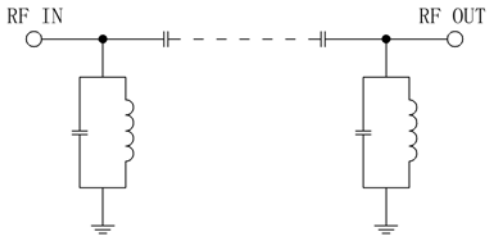
推荐装配图



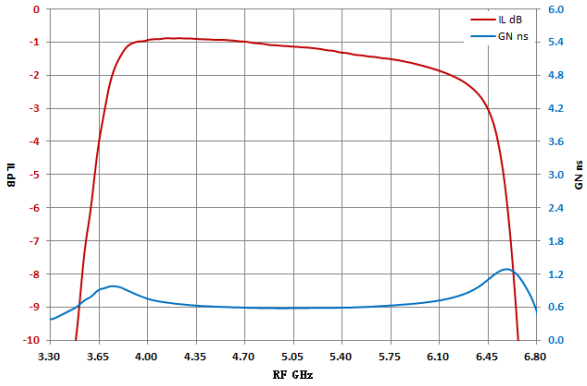
注意事项

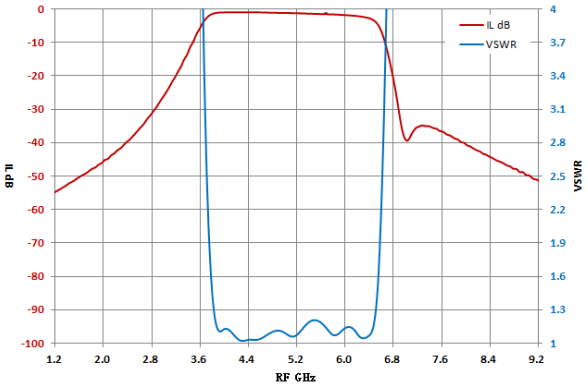
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

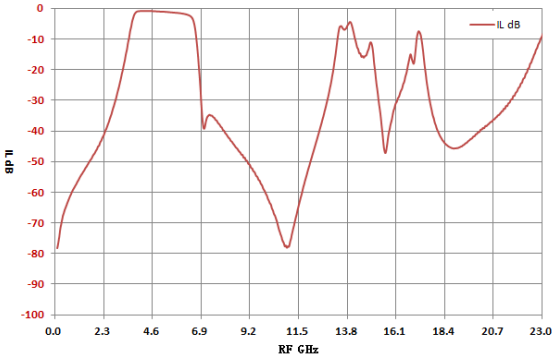
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

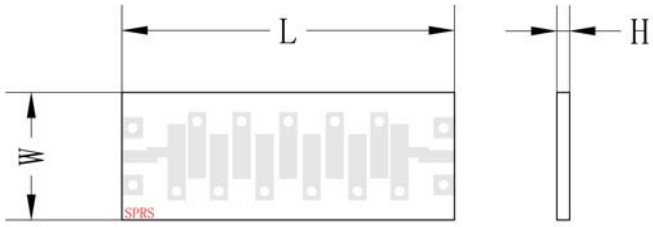
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	4.35	GHz
工作带宽	4.05-4.65	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	1.0	ns
带外抑制	40@DC-3.5GHz	dBc
带外抑制	40@5.3-11.0GHz	dBc

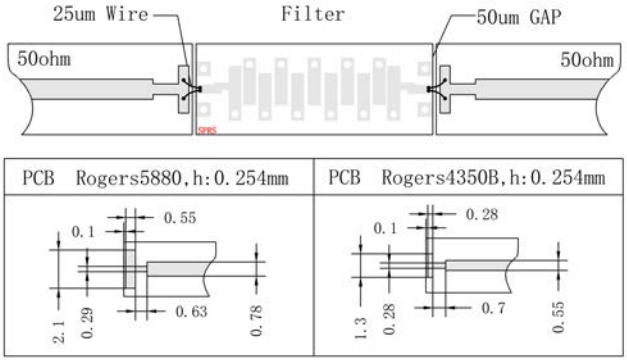
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.5，W：5.2，h：0.39

外形图：端口居中



推荐装配图



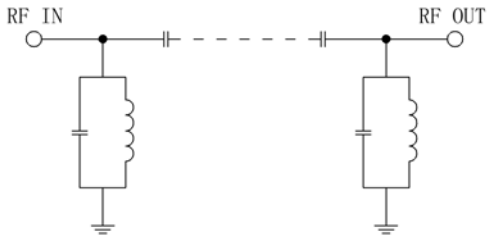
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

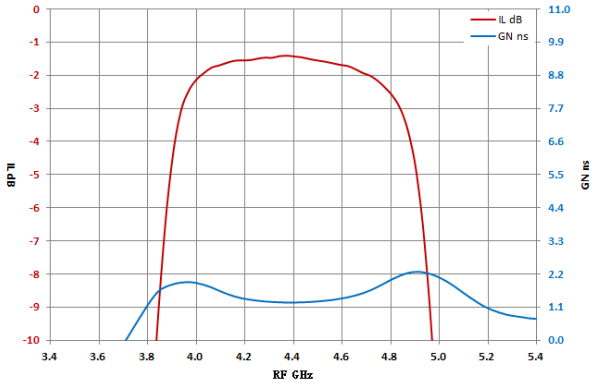
参考实物图

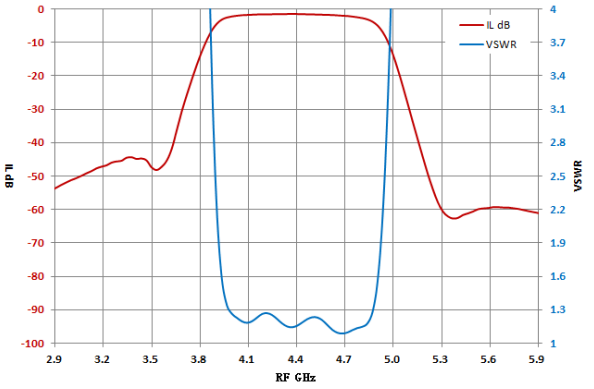


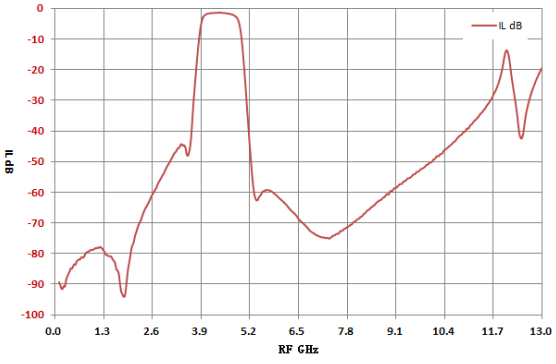
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



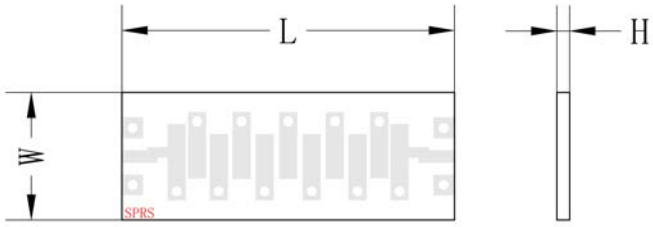
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	4.1	GHz
工作带宽	0	GHz
中心损耗	5.5	dB
带内波动	0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0	ns
带外抑制	40@DC-3.6GHz	dBc
带外抑制	40@4.7-10.0GHz	dBc

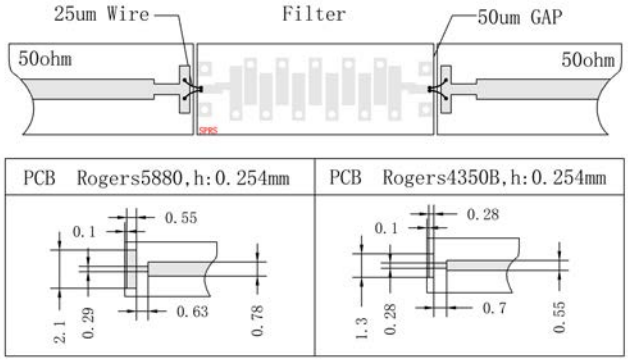
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：5.0，h：0.39

外形图：端口居中



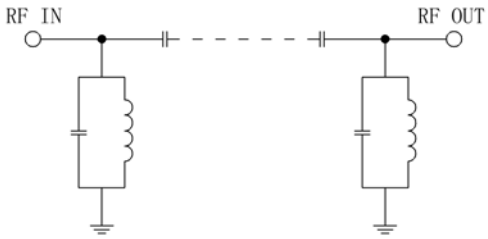
推荐装配图



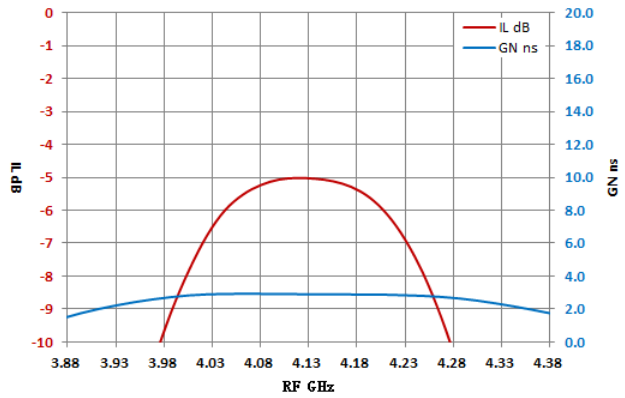
注意事项

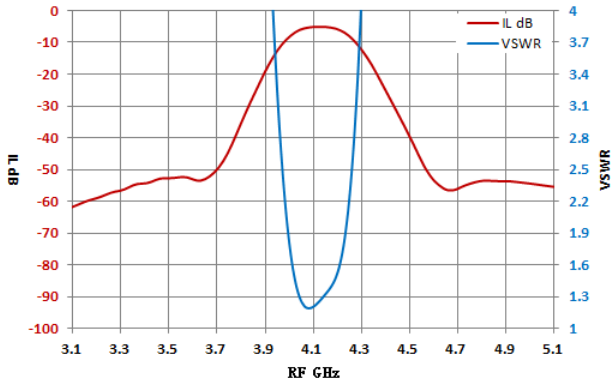
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.62mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

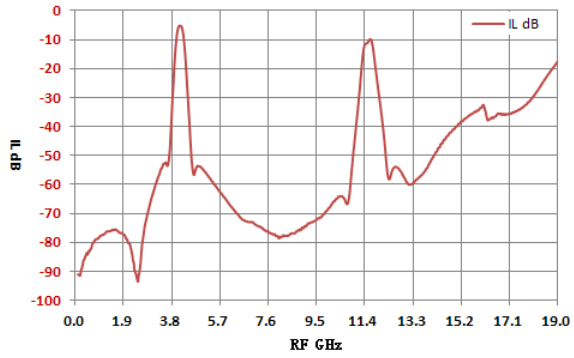
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

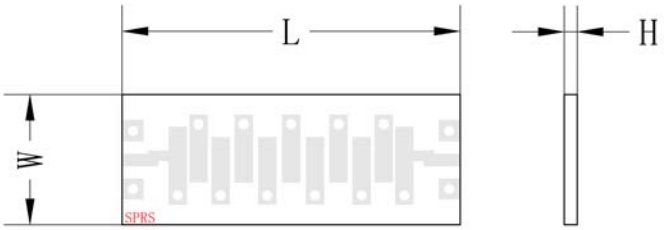
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	4.35	GHz
工作带宽	4.1-4.6	GHz
中心损耗	2.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.6	ns
带外抑制	35@DC-3.5GHz	dBc
带外抑制	30@5.3-10.0GHz	dBc

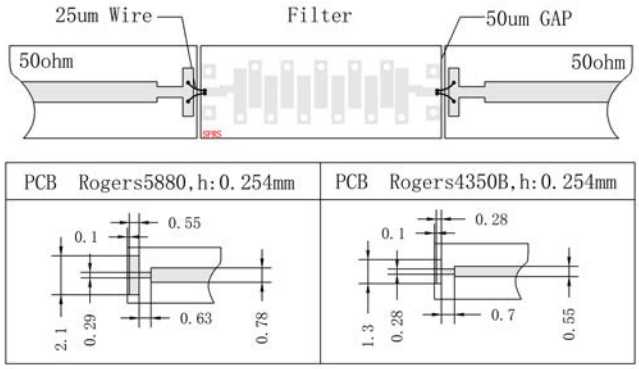
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：6.5，W：5.5，h：0.39

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.61mm,端口可互换;

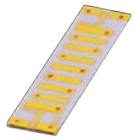
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

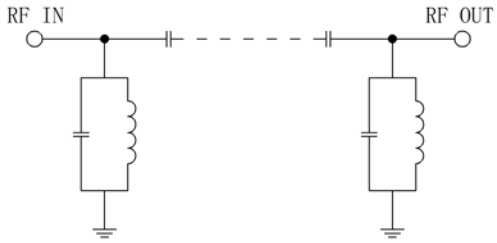
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

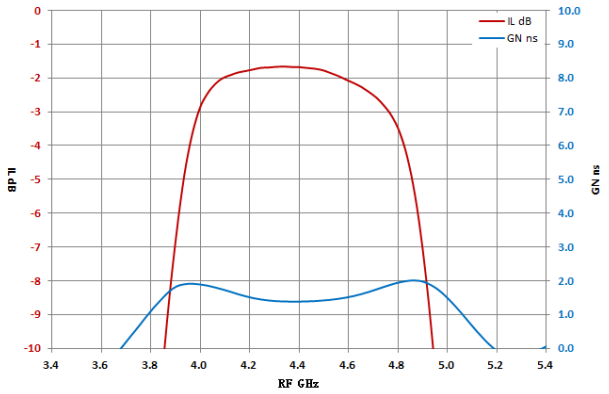
参考图

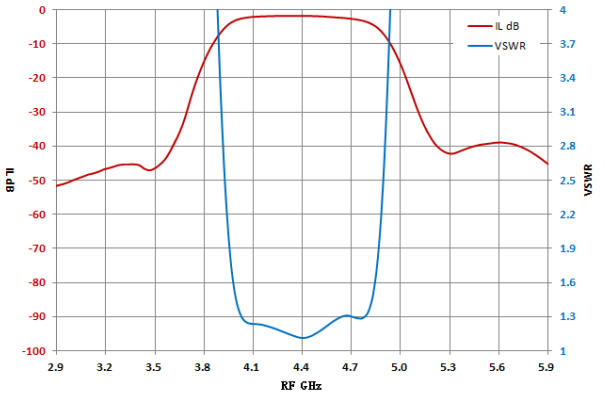


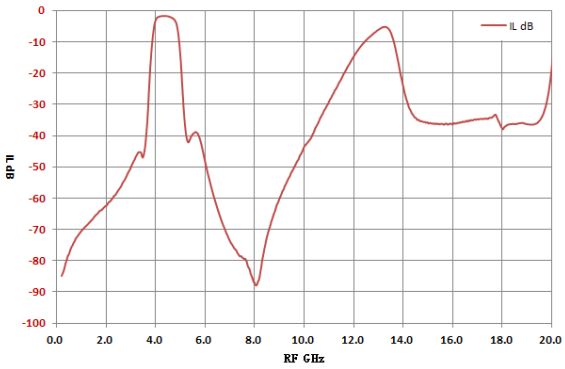
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

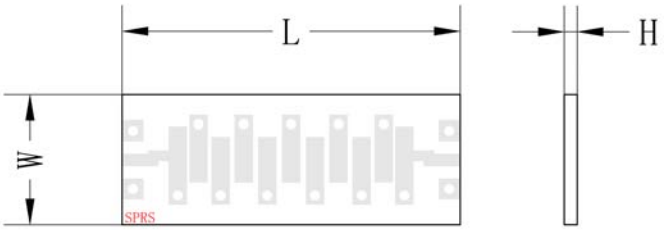
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	4.9	GHz
工作带宽	4.1-5.7	GHz
中心损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.6	ns
带外抑制	35@DC-3.4GHz	dBc
带外抑制	25@6.5-11.0GHz	dBc

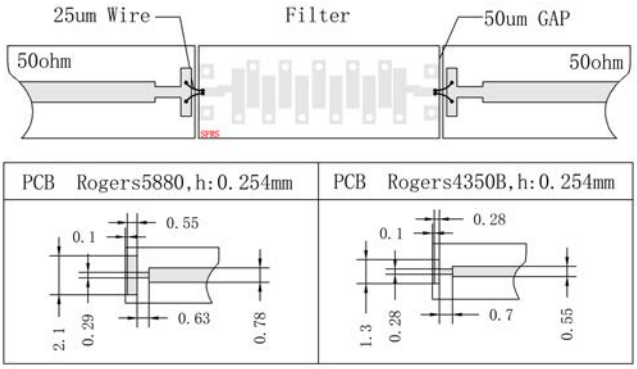
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：6.5，W：6.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

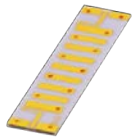
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

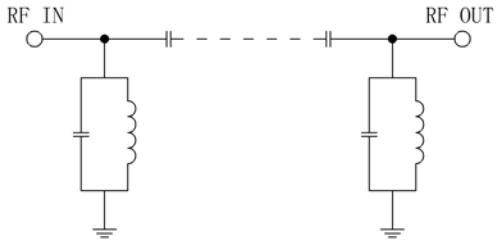
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

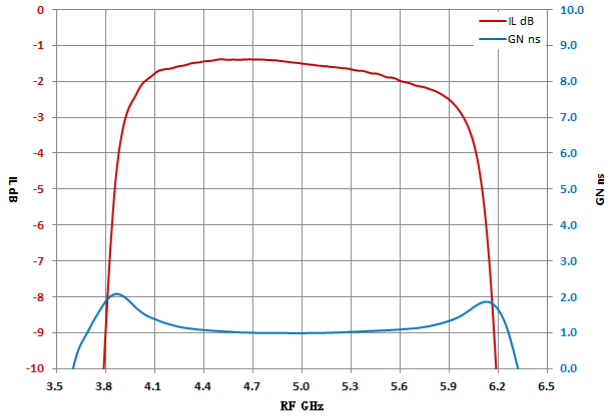
参考图

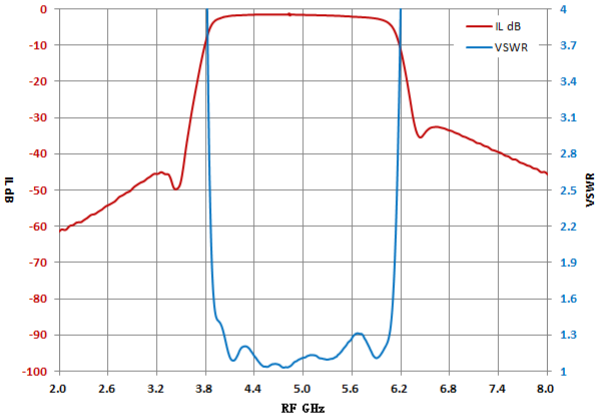


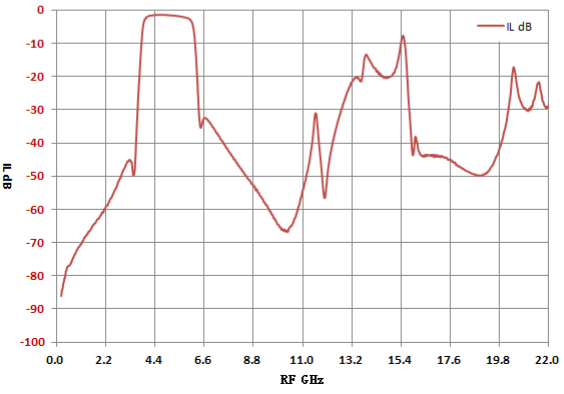
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

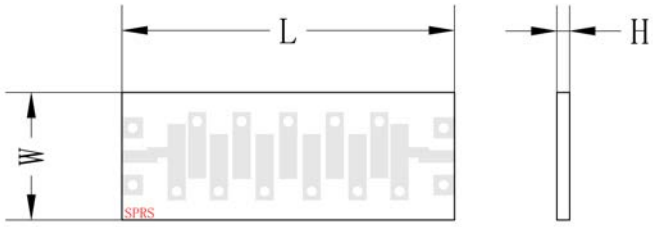
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	4.8	GHz
工作带宽	4.2-5.4	GHz
中心损耗	2.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-3.5GHz	dBc
带外抑制	40@6.3-11.0GHz	dBc

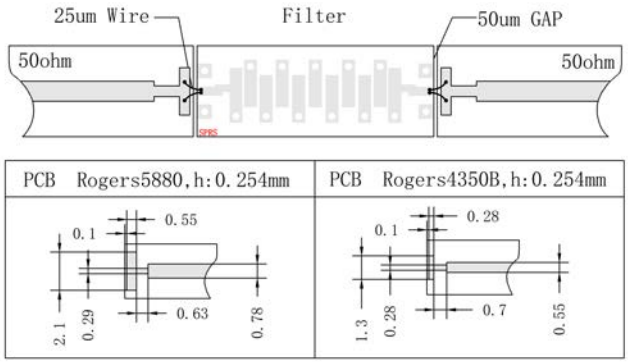
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：4.8，h：0.39

外形图：端口居中



推荐装配图



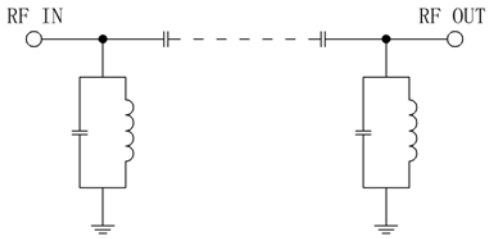
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.61mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

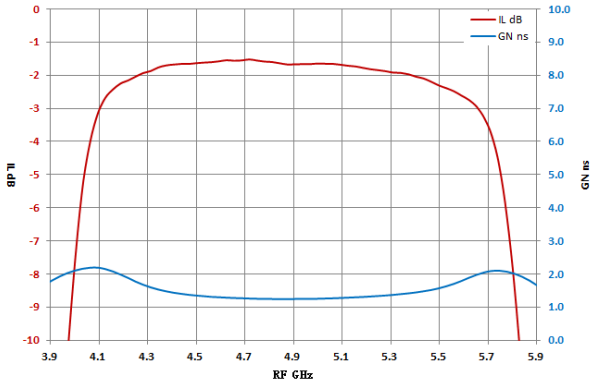
参考实物图

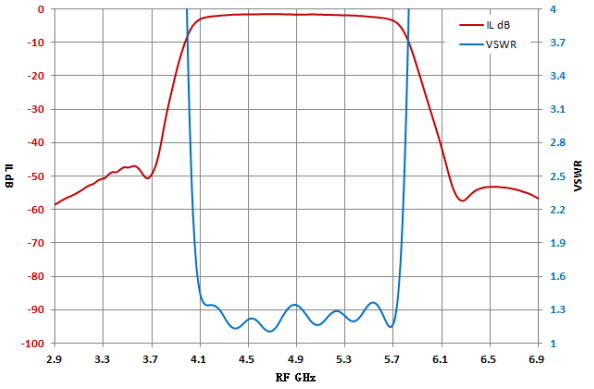


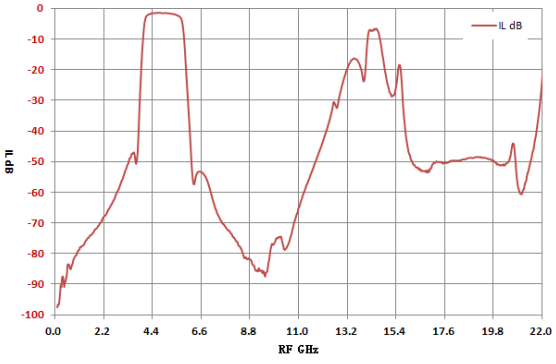
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

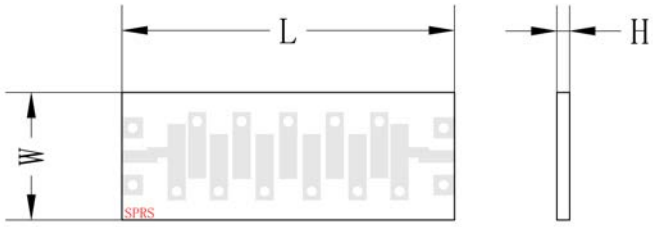
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	4.85	GHz
工作带宽	4.25-5.45	GHz
中心损耗	1.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	1.0	ns
带外抑制	40@DC-3.5GHz	dBc
带外抑制	40@6.3-11.0GHz	dBc

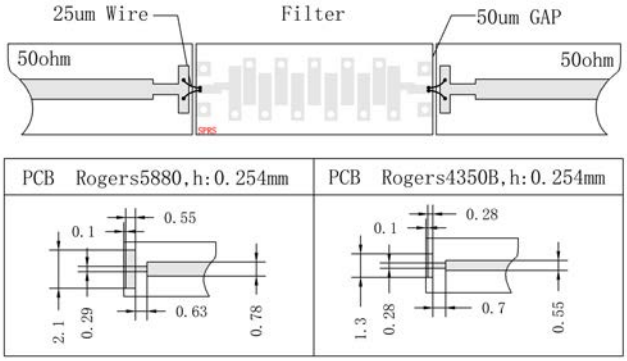
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：4.8，h：0.39

外形图：端口居中



推荐装配图



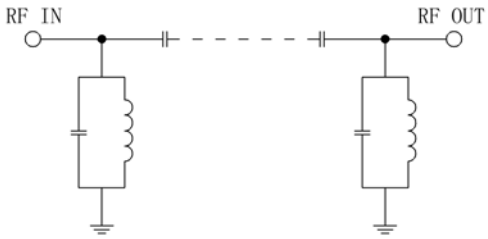
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

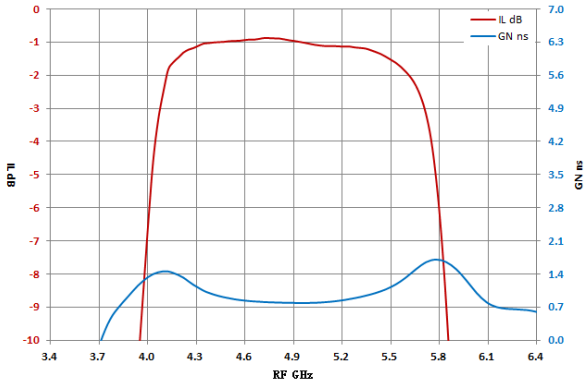
参考实物图

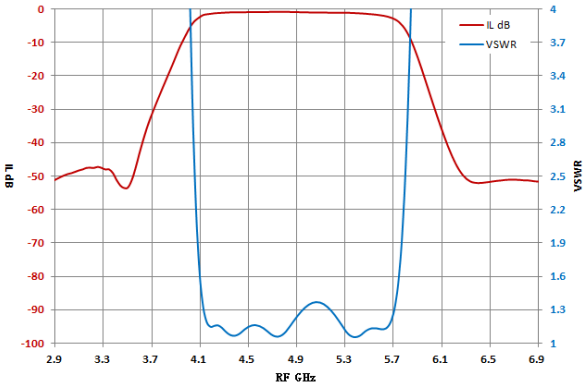


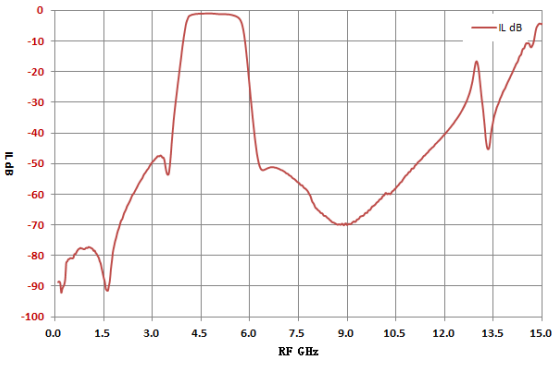
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

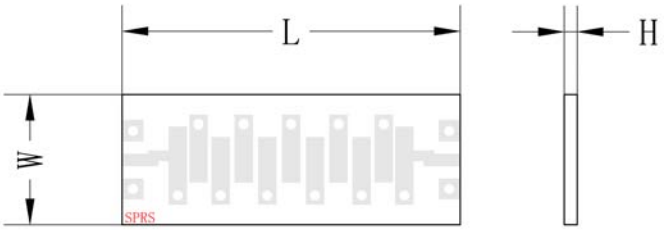
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	4.55	GHz
工作带宽	4.3-4.8	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.6	ns
带外抑制	35@DC-3.6GHz	dBc
带外抑制	35@5.6-10.0GHz	dBc

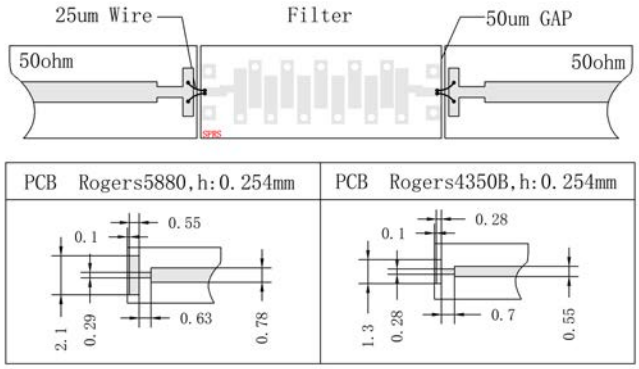
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：6.5，W：5.5，h：0.39

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.61mm,端口可互换;

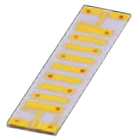
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

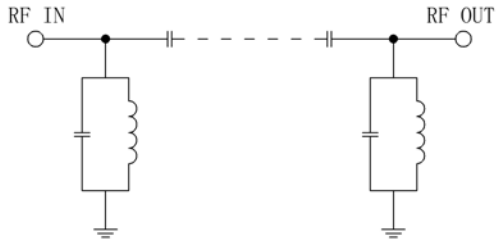
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

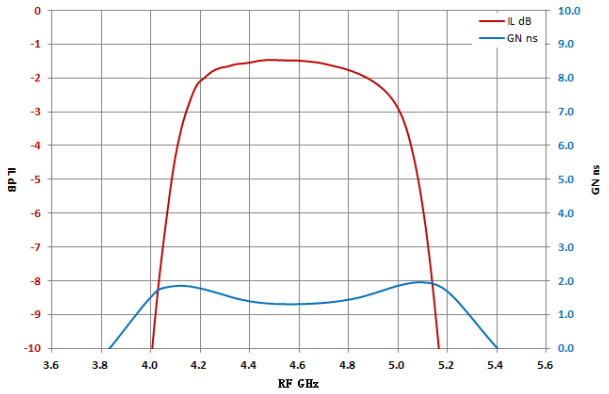
参考图

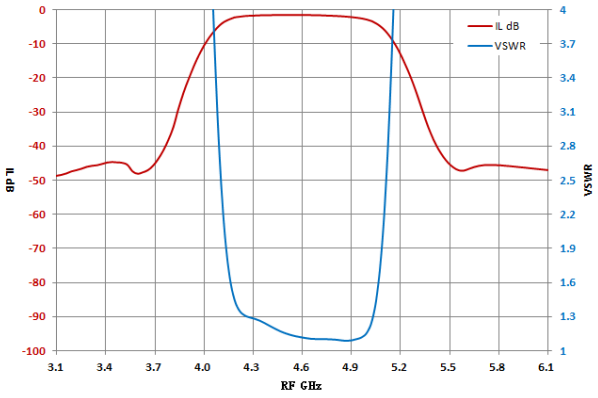


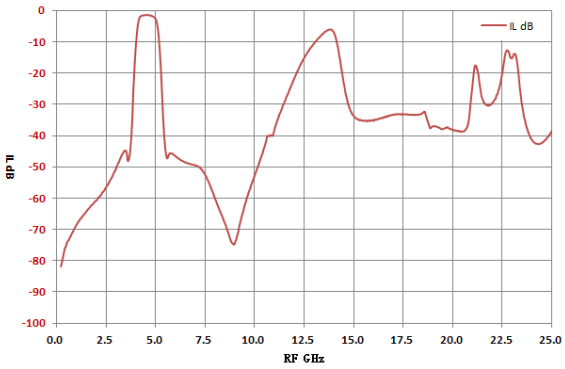
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



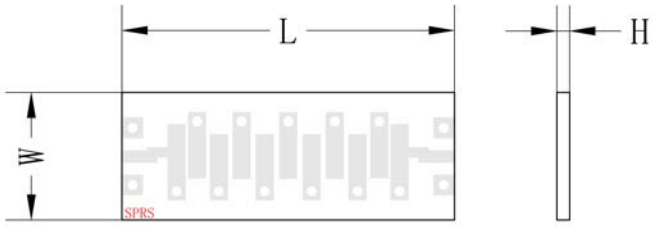
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	5.4	GHz
工作带宽	4.3-6.4	GHz
中心损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-3.4GHz	dBc
带外抑制	35@7.6-13.0GHz	dBc

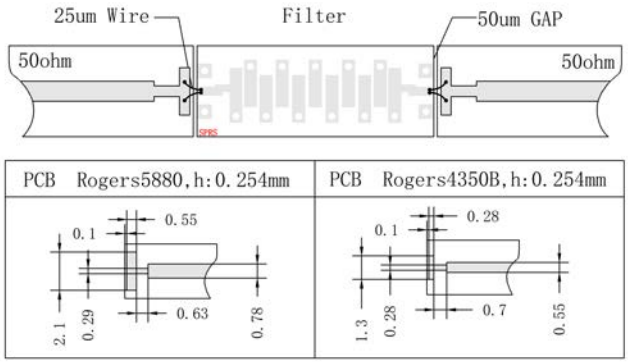
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：5.5，h：0.26

外形图：端口居中



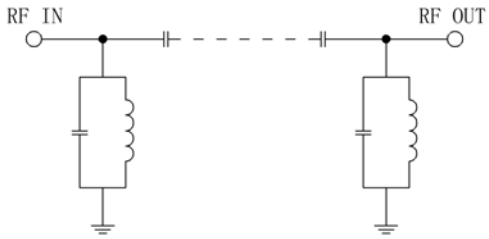
推荐装配图



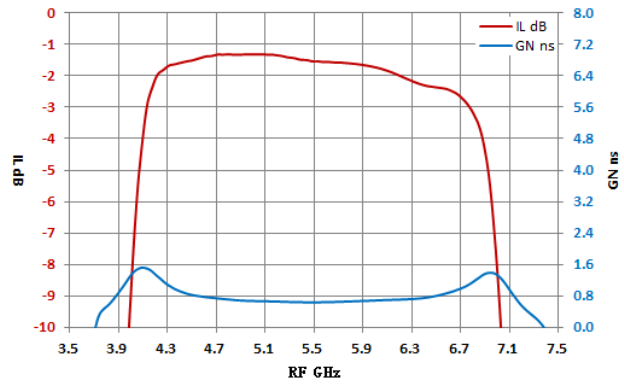
注意事项

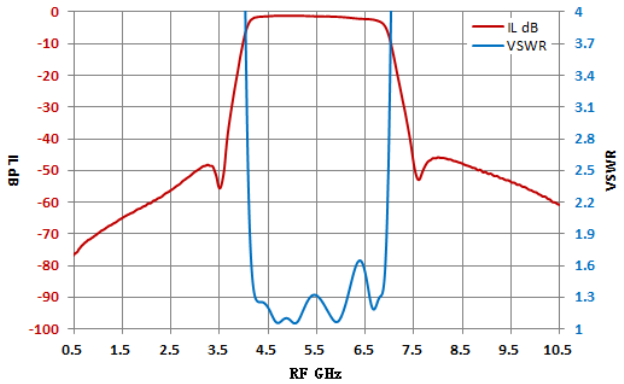
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

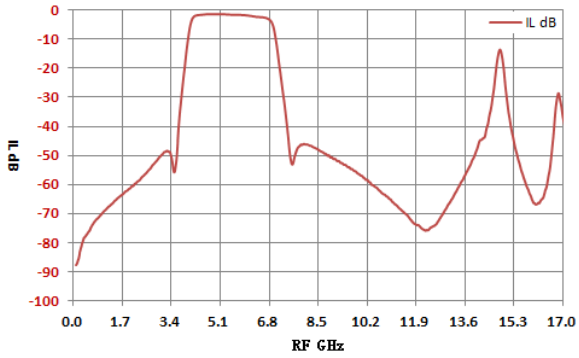
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



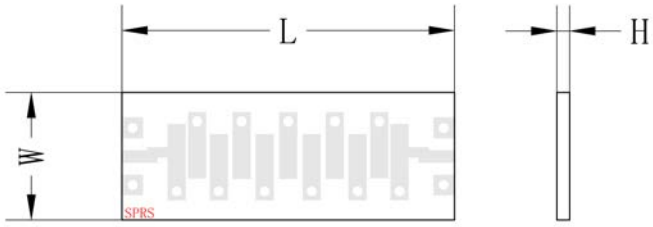
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	4.45	GHz
工作带宽	4.4-4.5	GHz
中心损耗	4.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	35@DC-3.9GHz	dBc
带外抑制	40@5.0-11.5GHz	dBc

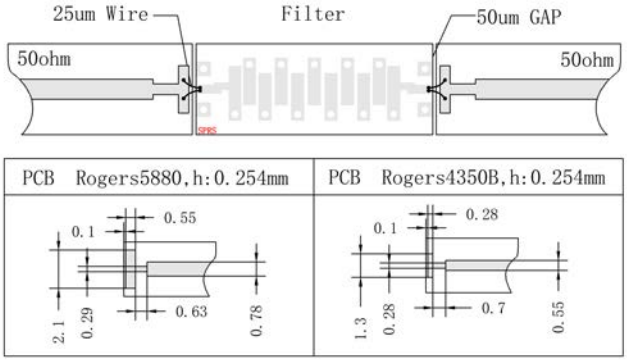
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：5.5，h：0.39

外形图：端口居中



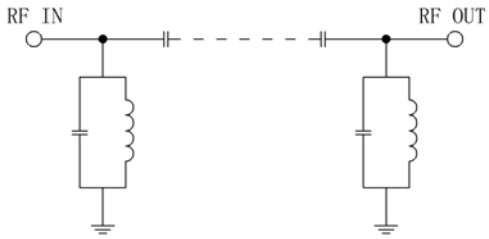
推荐装配图



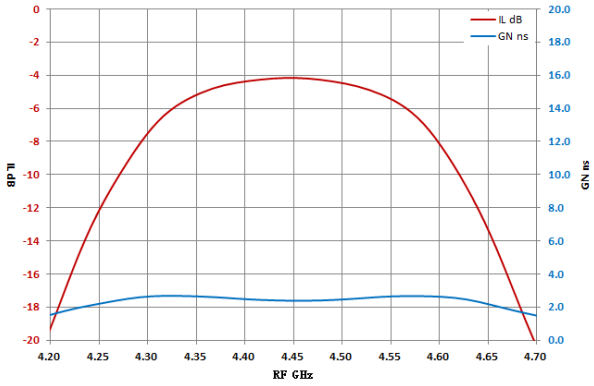
注意事项

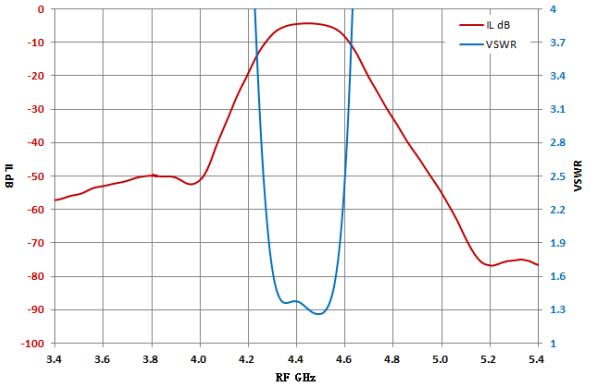
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.62mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

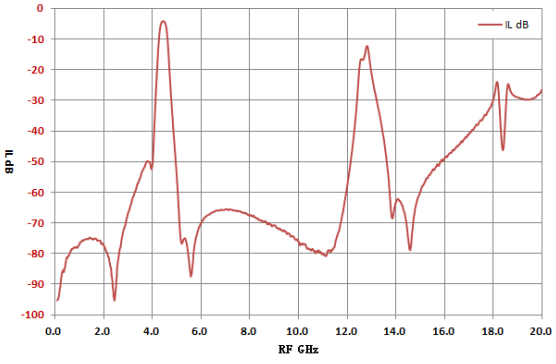
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

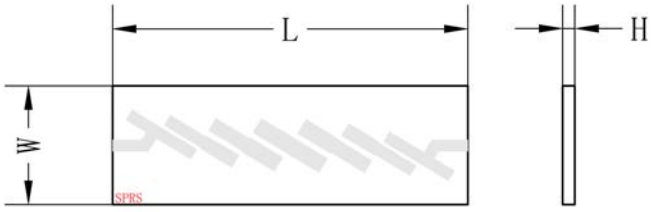
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	4.65	GHz
工作带宽	4.45-4.85	GHz
中心损耗	4.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-3.2GHz	dBc
带外抑制	40@6.3-8.0GHz	dBc

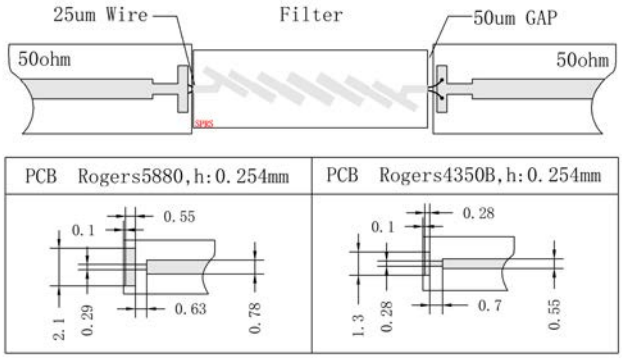
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：6.3，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



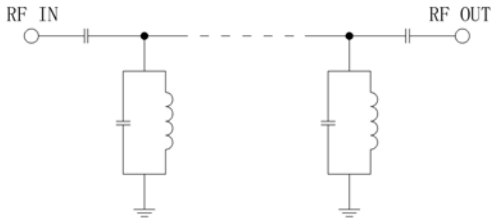
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.74mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

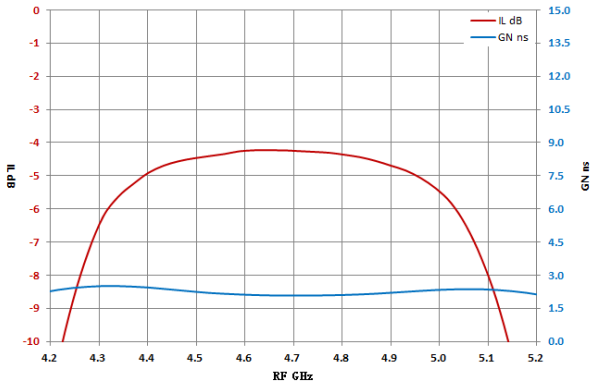
参考实物图

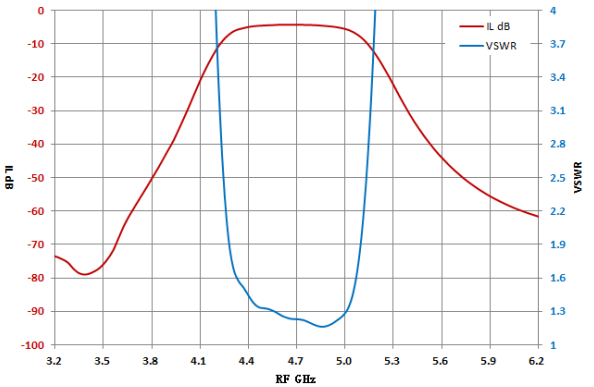


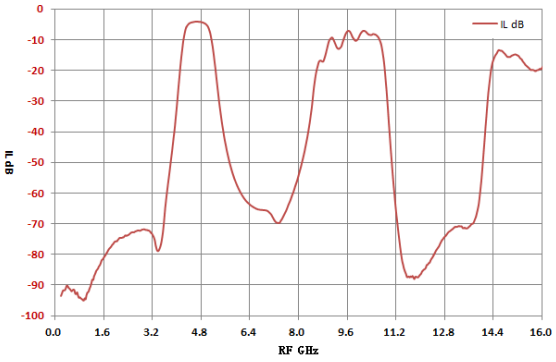
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

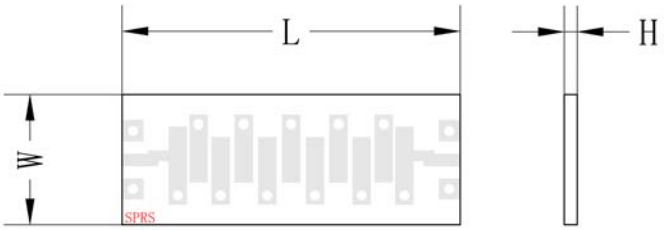
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	4.8	GHz
工作带宽	4.5-5.1	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.6	ns
带外抑制	40@DC-3.7GHz	dBc
带外抑制	40@5.9-10.0GHz	dBc

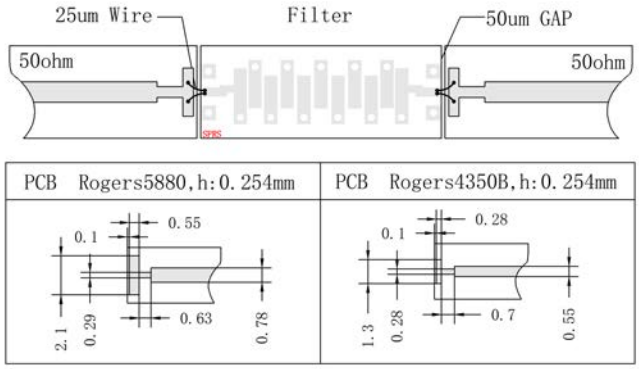
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：6.0，W：5.0，h：0.39

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.61mm,端口可互换;

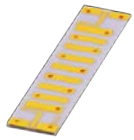
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

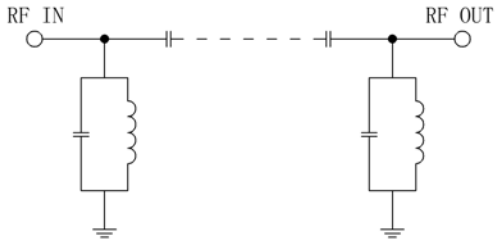
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

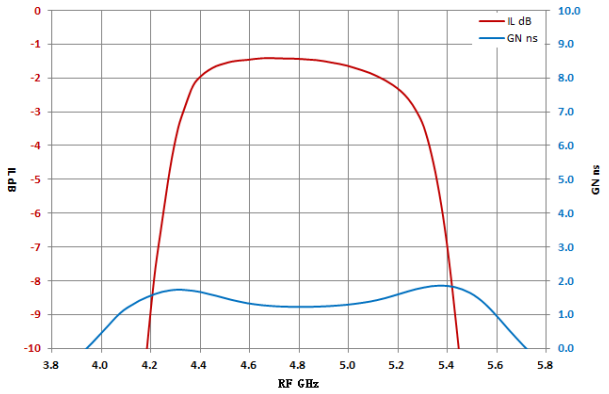
参考图

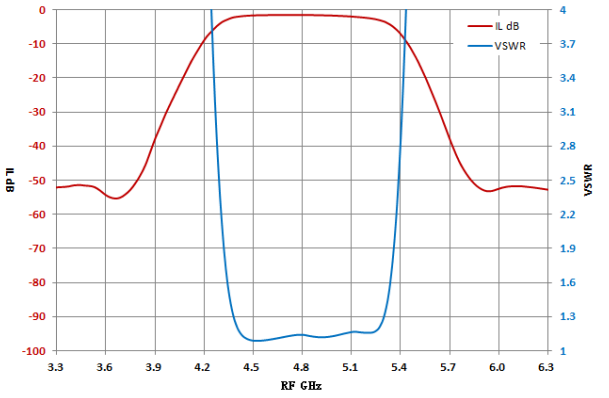


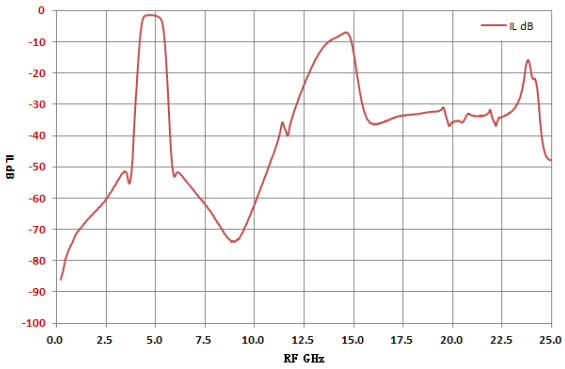
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



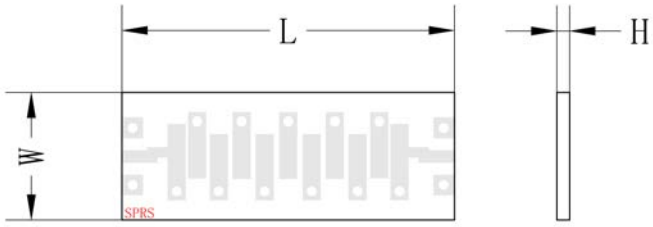
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	5.2	GHz
工作带宽	4.5-5.8	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-3.7GHz	dBc
带外抑制	38@6.7-12.0GHz	dBc

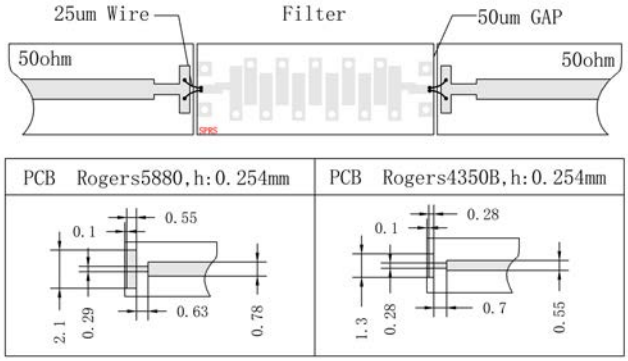
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：6.5，h：0.26

外形图：端口居中



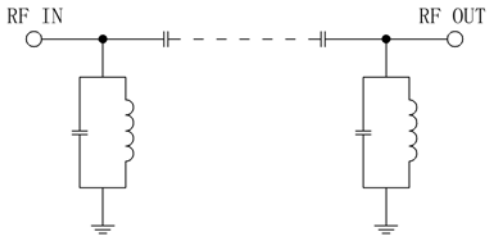
推荐装配图



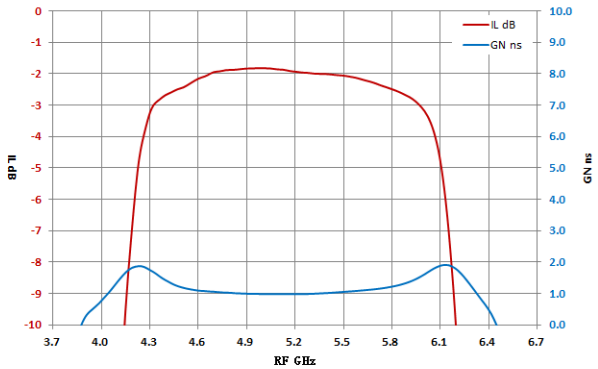
注意事项

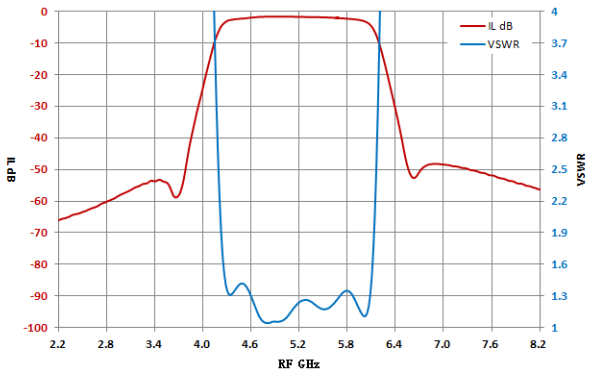
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

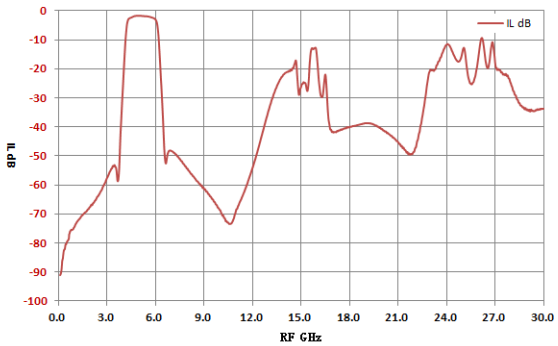
原理图



典型曲线







产品特点

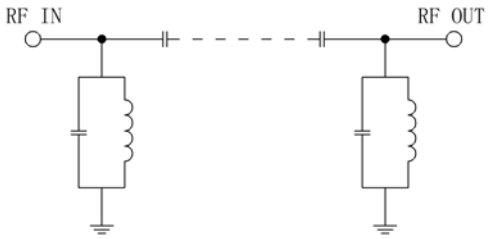
高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



技术要求

项目	参数	单位
中心频率	4.6	GHz
工作带宽	0	GHz
中心损耗	5.6	dB
带内波动	0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0	ns
带外抑制	40@DC-4.1GHz	dBc
带外抑制	40@5.1-12.0GHz	dBc

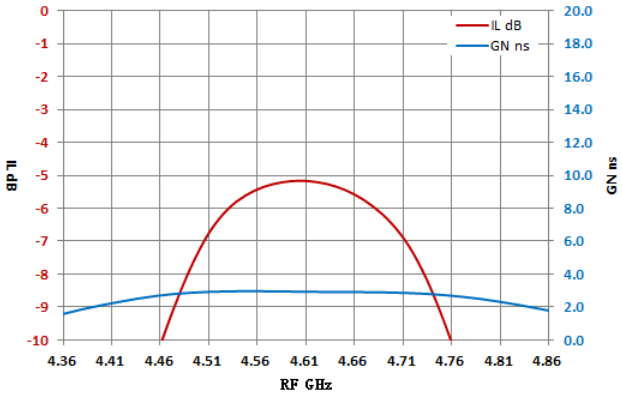
原理图

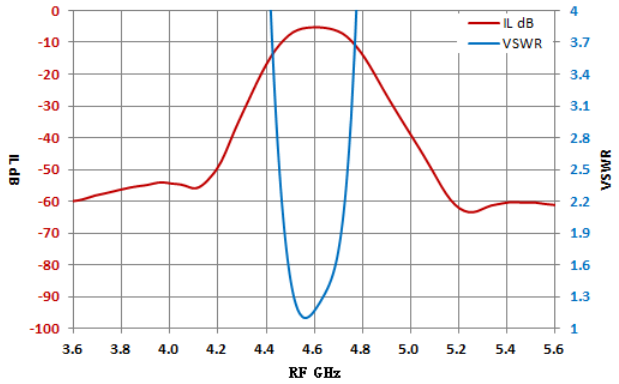


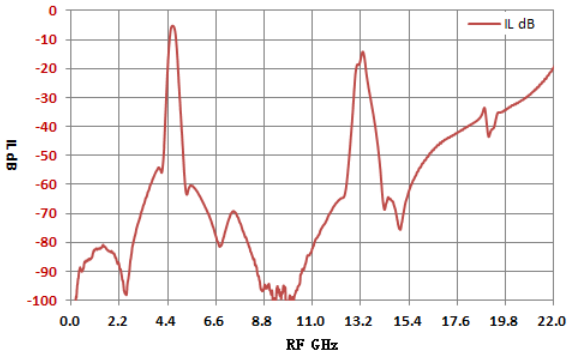
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：4.5，h：0.39

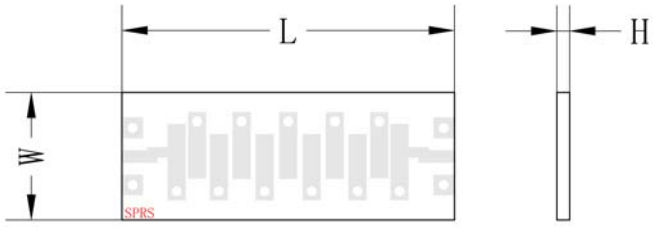
典型曲线



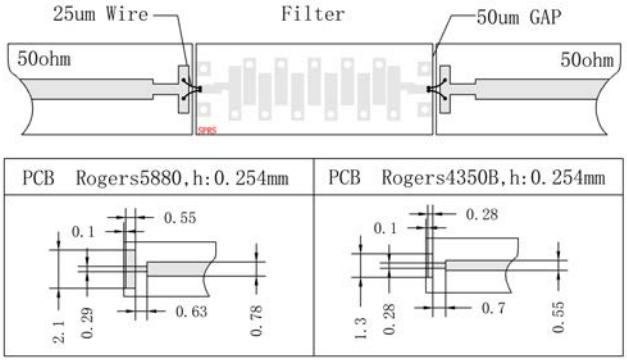




外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.62mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

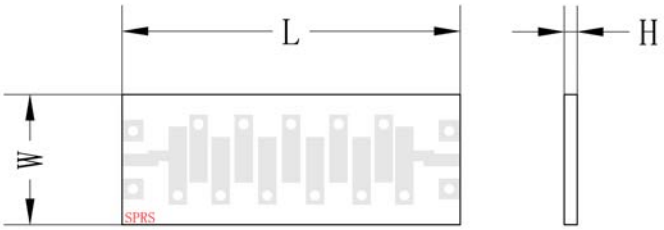
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	4.95	GHz
工作带宽	4.6-5.3	GHz
中心损耗	1.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.6	ns
带外抑制	40@DC-3.8GHz	dBc
带外抑制	40@6.1-11.0GHz	dBc

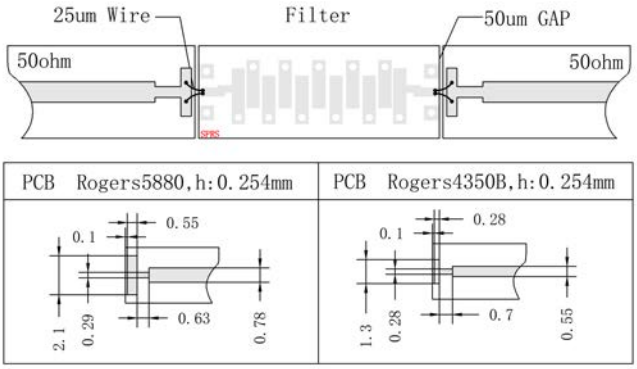
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：6.5，W：5.0，h：0.39

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.61mm,端口可互换;

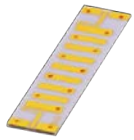
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

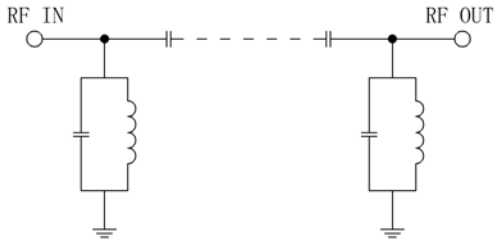
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

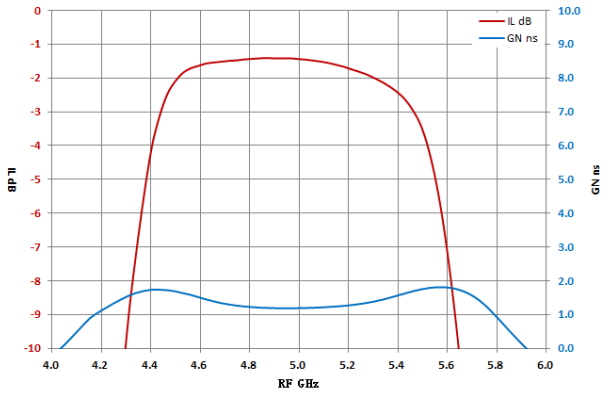
参考图

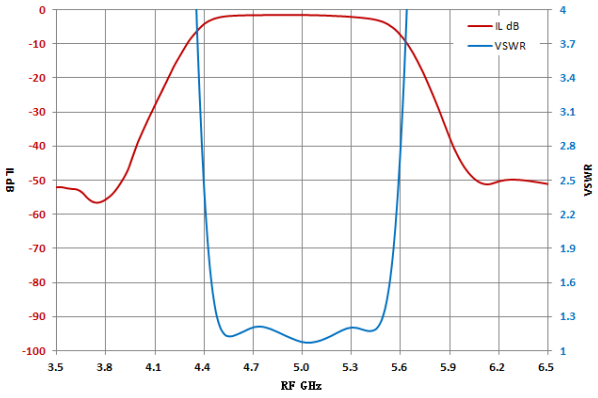


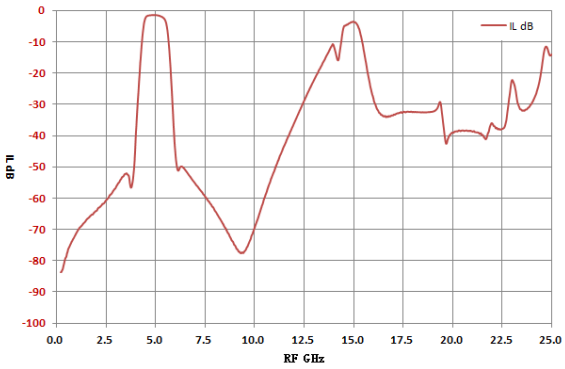
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

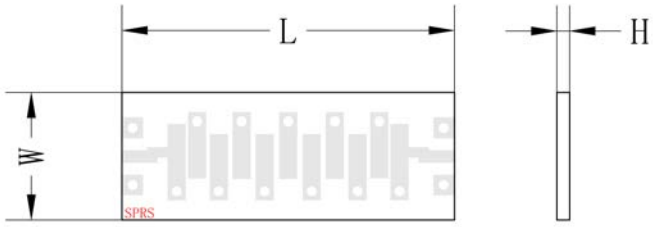
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	5.0	GHz
工作带宽	4.6-5.4	GHz
中心损耗	2.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-3.9GHz	dBc
带外抑制	40@6.5-11.0GHz	dBc

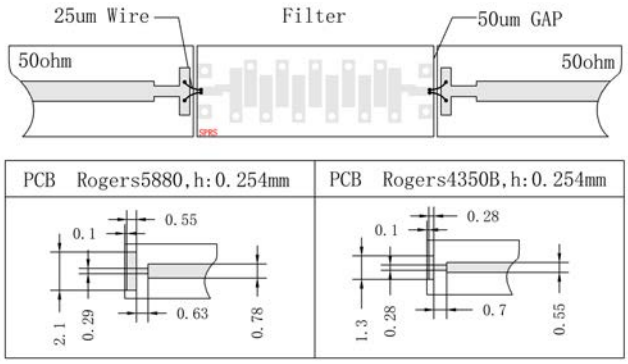
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：6.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



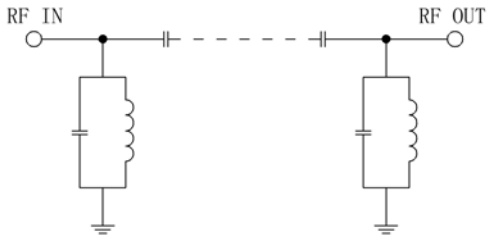
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

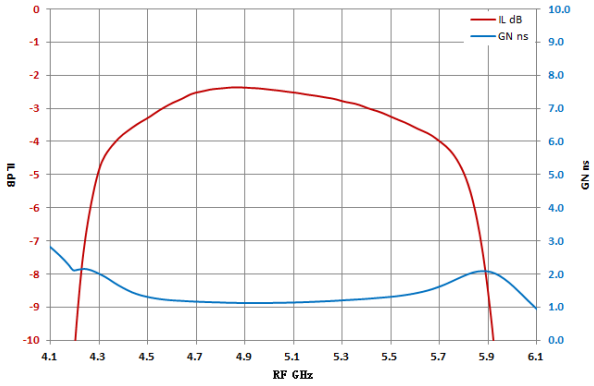
参考实物图

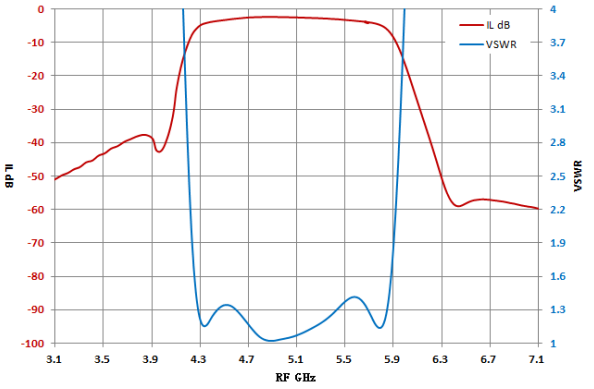


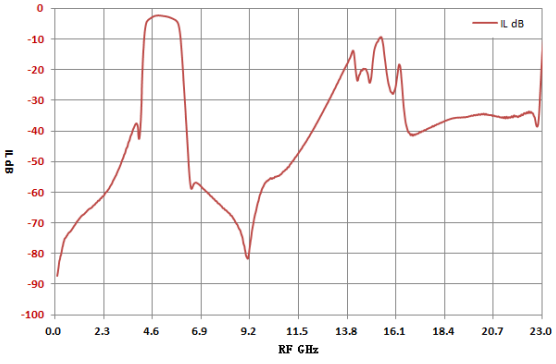
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



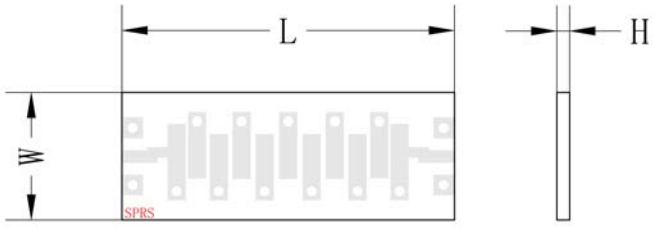
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	5.7	GHz
工作带宽	4.8-6.6	GHz
中心损耗	2.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.7	ns
带外抑制	40@DC-3.7GHz	dBc
带外抑制	40@8.2-13.0GHz	dBc

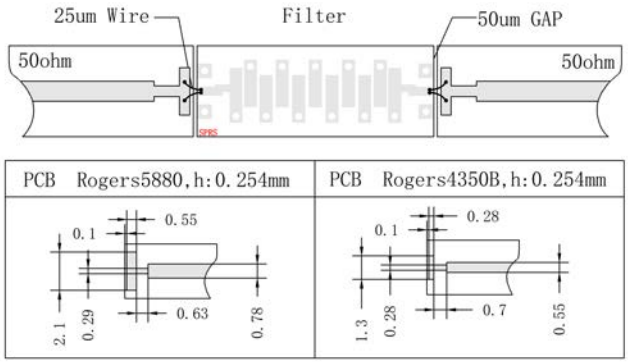
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：5.5，h：0.26

外形图：端口居中



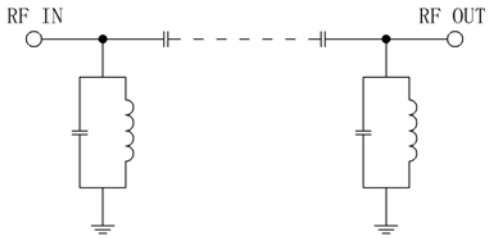
推荐装配图



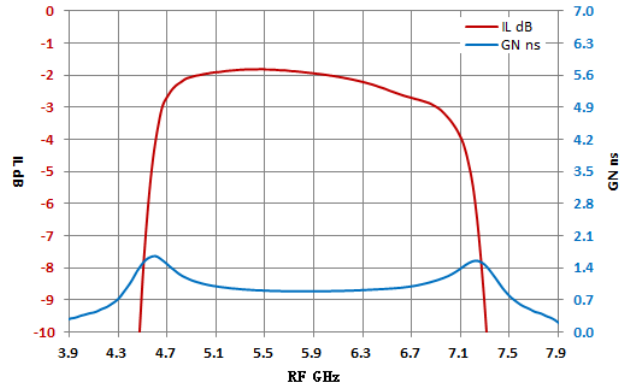
注意事项

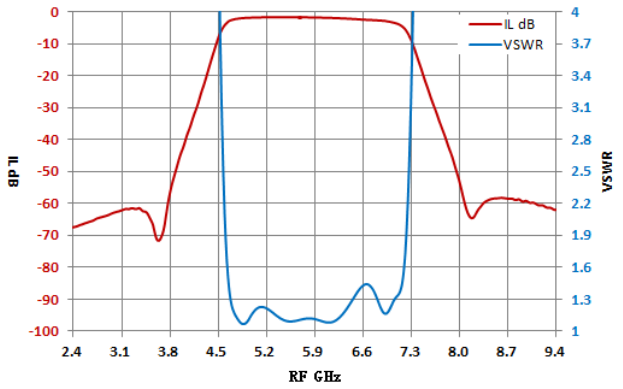
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

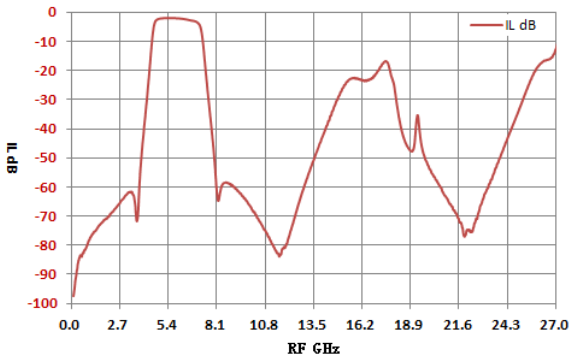
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

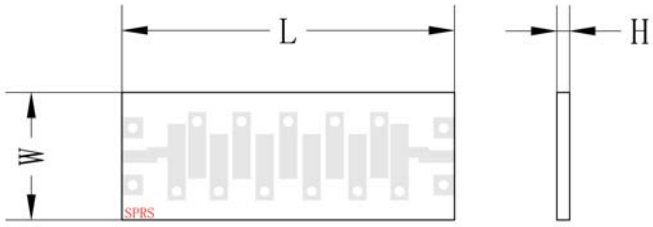
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	4.95	GHz
工作带宽	4.9-5.0	GHz
中心损耗	4.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-4.5GHz	dBc
带外抑制	40@5.5-12.0GHz	dBc

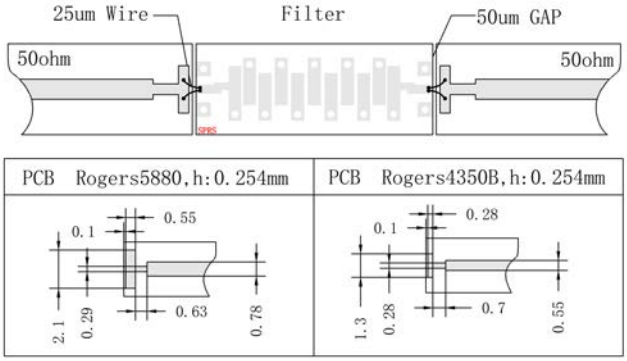
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：5.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



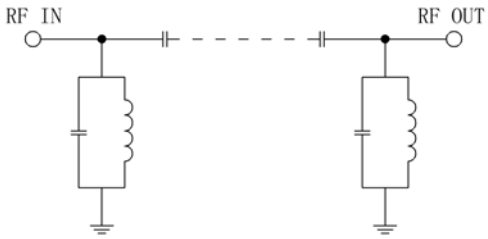
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.62mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

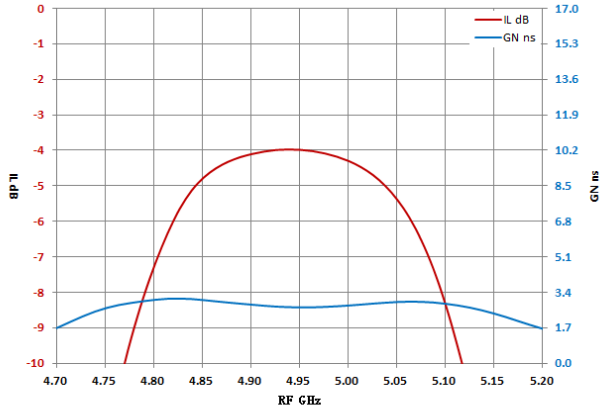
参考实物图

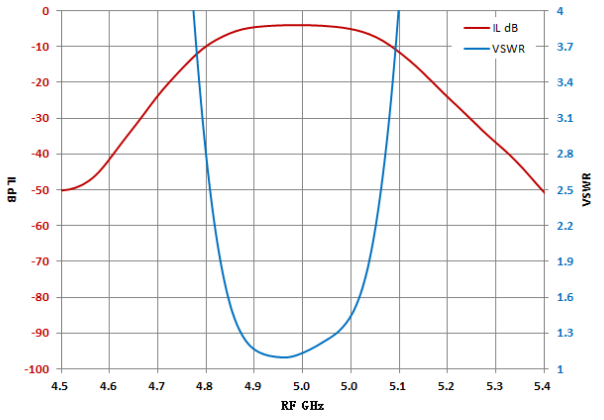


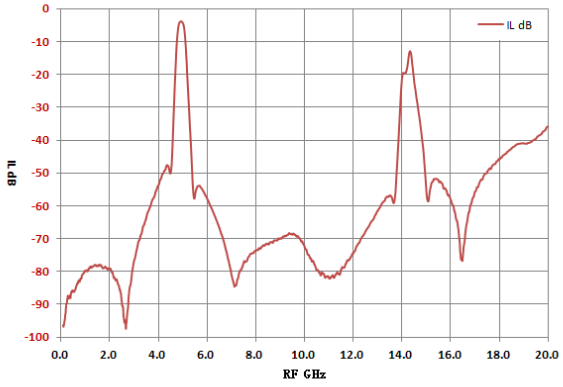
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

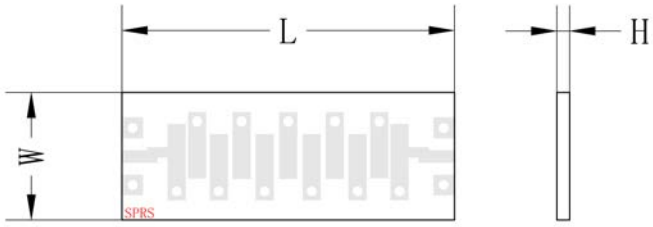
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	5.6	GHz
工作带宽	4.9-6.3	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-4.2GHz	dBc
带外抑制	40@7.2-14.0.0GHz	dBc

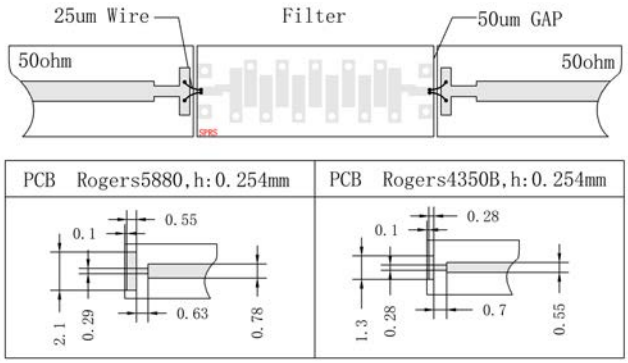
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.5，W：4.2，h：0.39

外形图：端口居中



推荐装配图



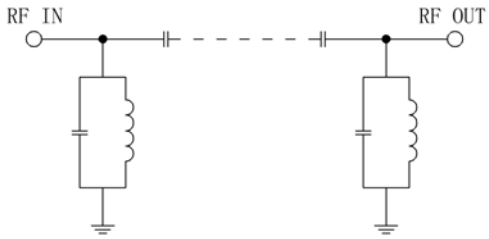
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.61mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

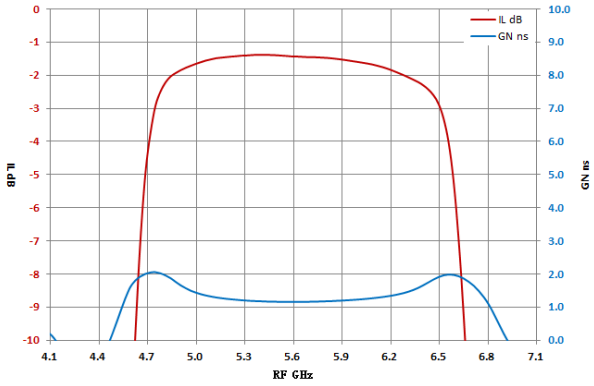
参考实物图

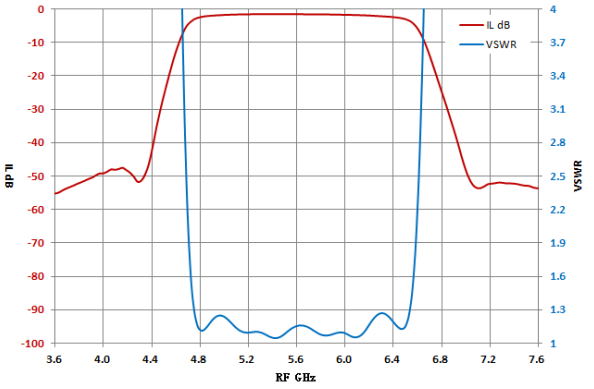


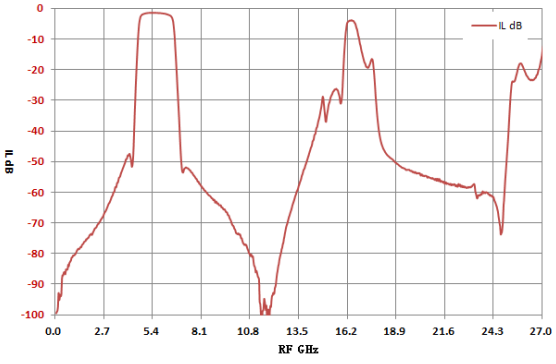
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

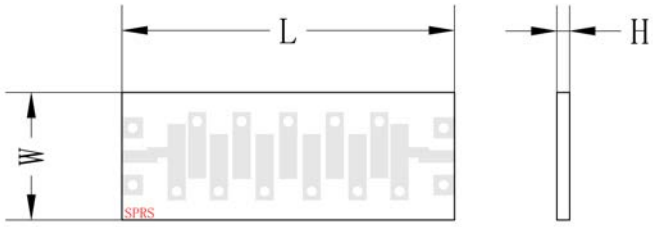
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	5.7	GHz
工作带宽	4.9-6.5	GHz
中心损耗	1.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-4.2GHz	dBc
带外抑制	40@7.0-13.0.0GHz	dBc

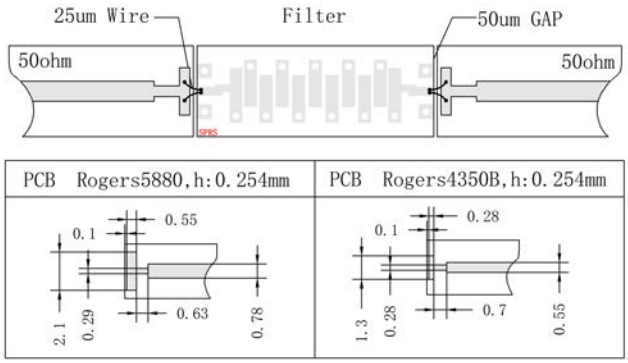
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.5，W：4.2，h：0.39

外形图：端口居中



推荐装配图



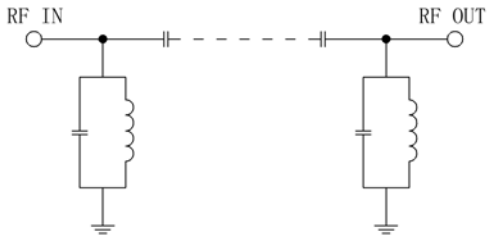
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.61mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

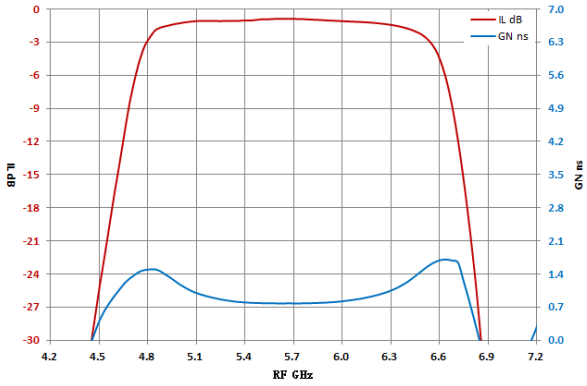
参考实物图

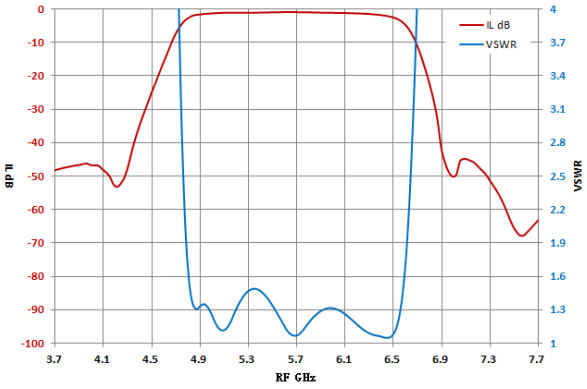


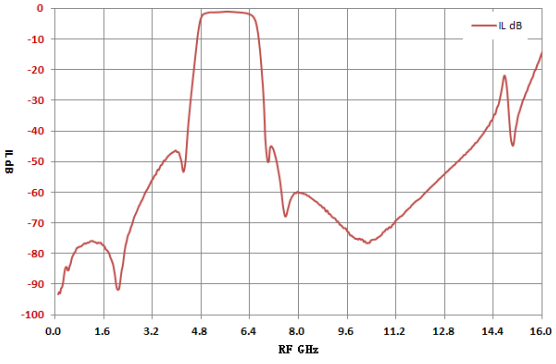
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



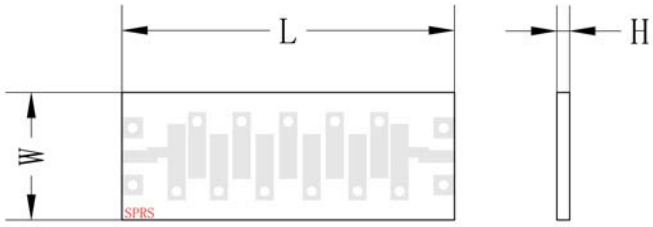
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	6.1	GHz
工作带宽	4.9-7.2	GHz
中心损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-4.1GHz	dBc
带外抑制	40@8.5-14.0GHz	dBc

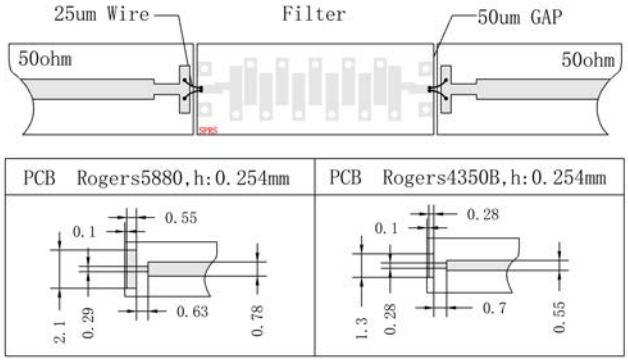
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：5.5，h：0.26

外形图：端口居中



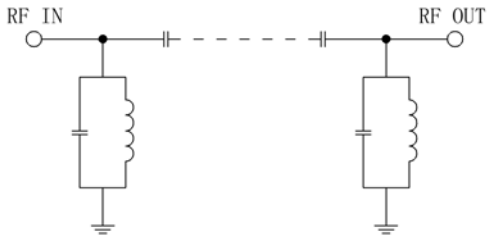
推荐装配图



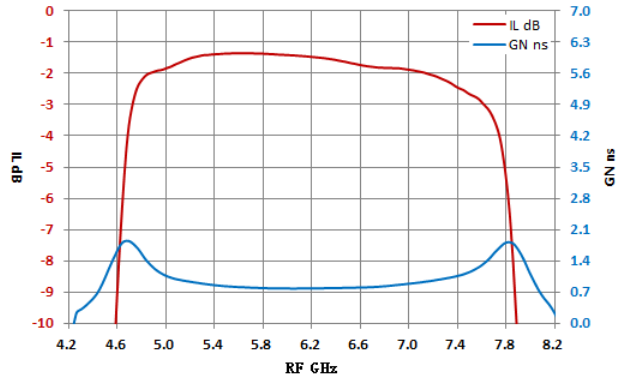
注意事项

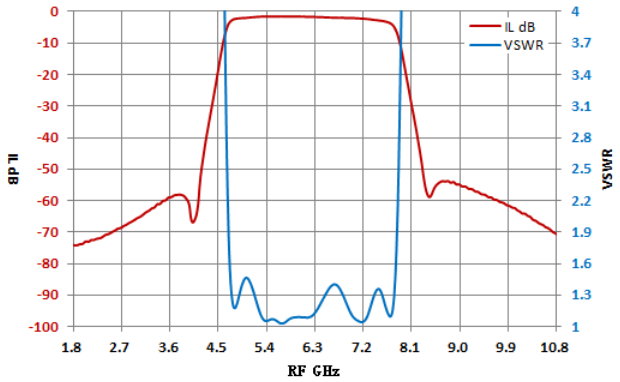
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

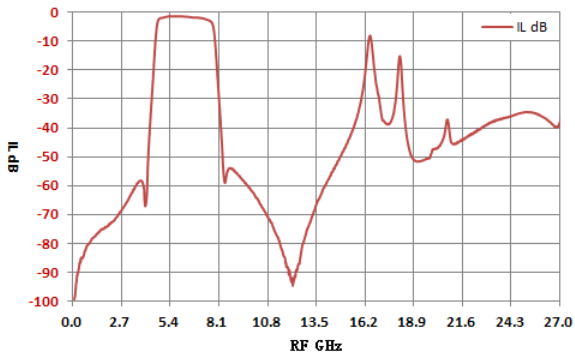
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



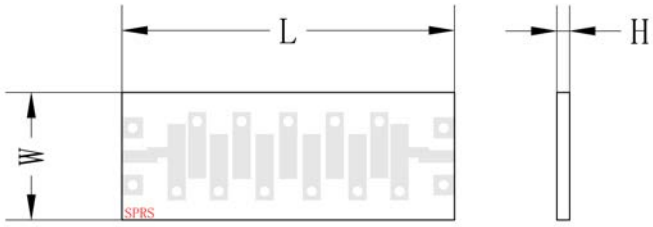
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	6.4	GHz
工作带宽	4.9-7.9	GHz
中心损耗	2.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-1.3GHz	dBc
带外抑制	35@10.0-15.0GHz	dBc

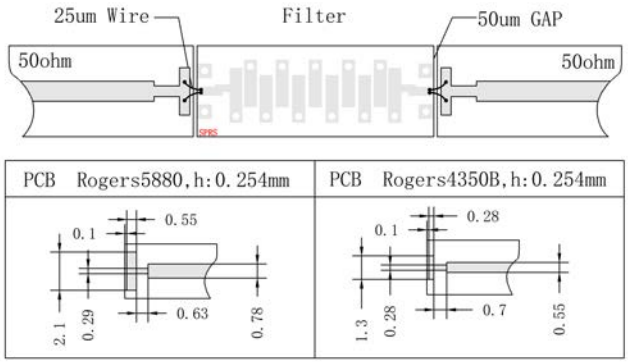
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：5.0，h：0.26

外形图：端口居中



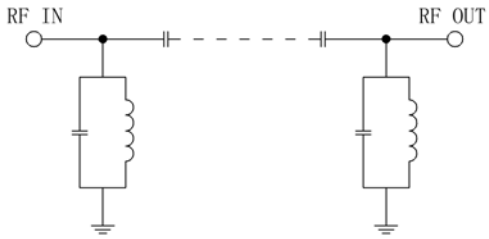
推荐装配图



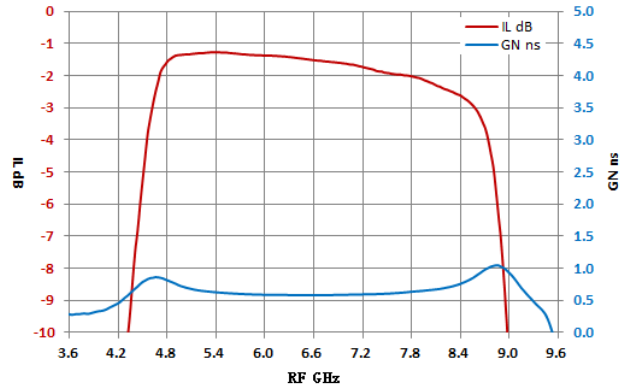
注意事项

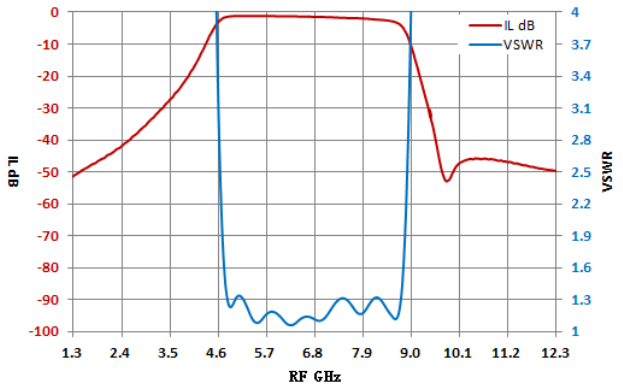
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

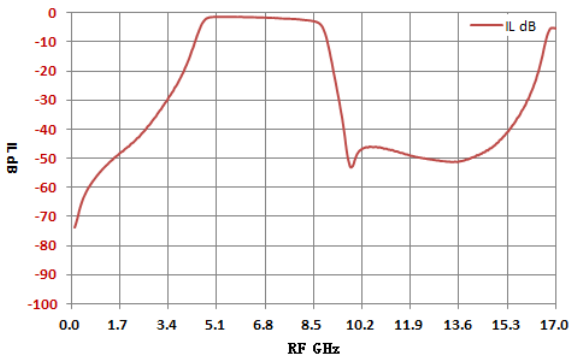
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



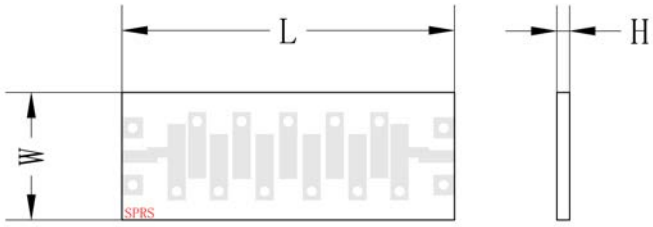
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	5.0	GHz
工作带宽	4.95-5.05	GHz
中心损耗	3.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-4.0GHz	dBc
带外抑制	40@6.0-12.0GHz	dBc

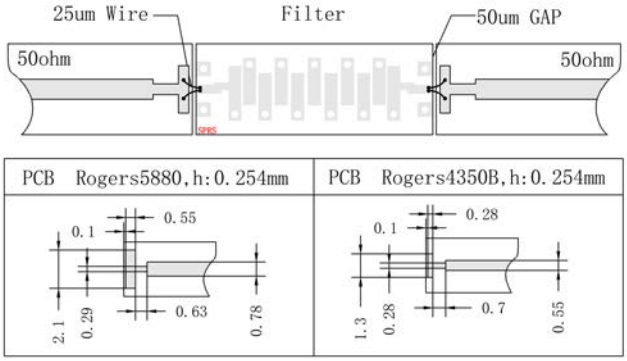
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



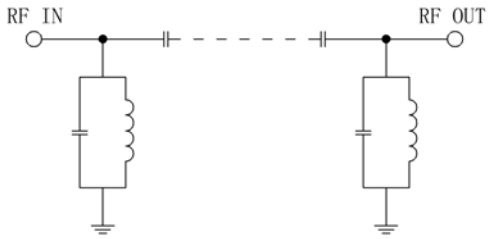
推荐装配图



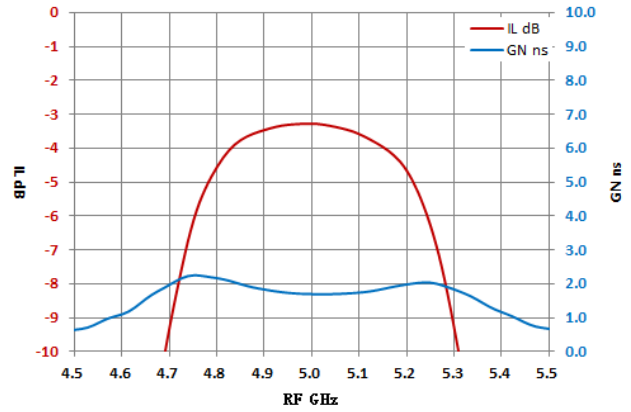
注意事项

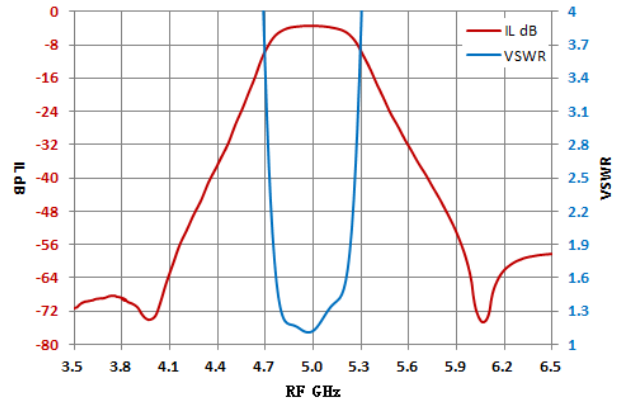
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

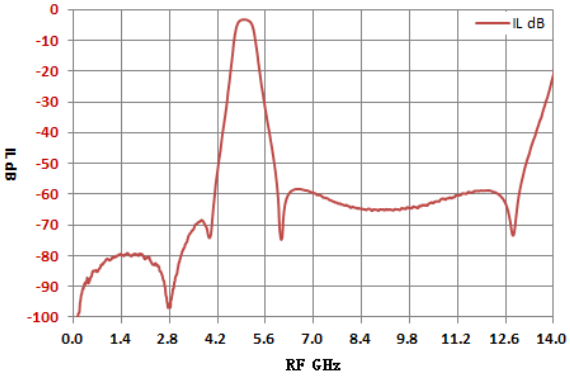
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

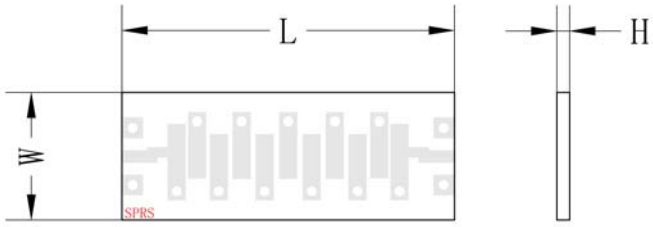
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	5.35	GHz
工作带宽	4.95-4.75	GHz
中心损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-4.2GHz	dBc
带外抑制	40@6.3-12.0GHz	dBc

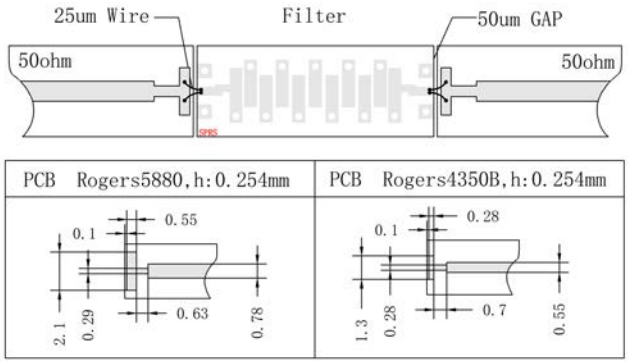
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：4.2，h：0.39

外形图：端口居中



推荐装配图



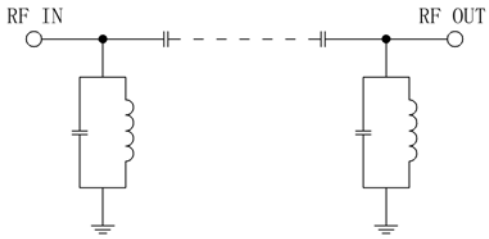
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.61mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

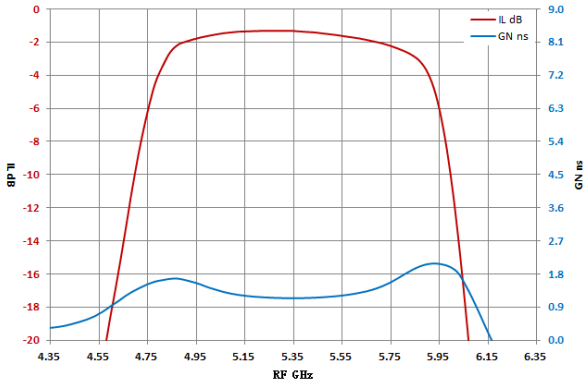
参考实物图

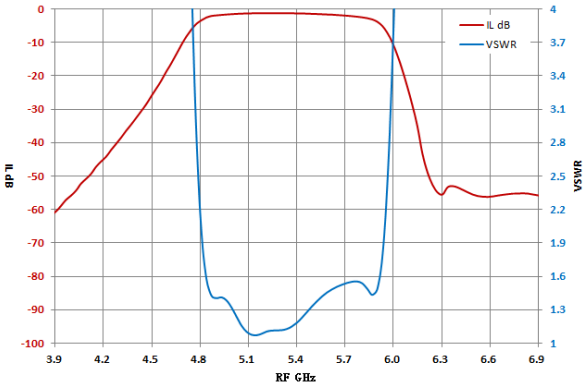


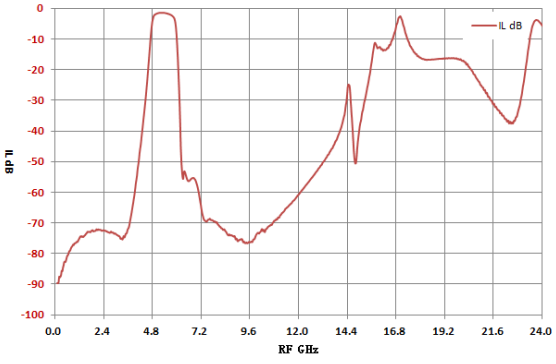
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



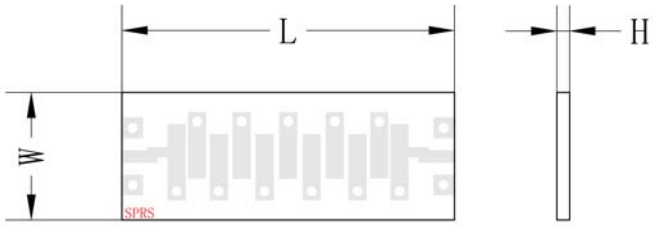
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	5.5	GHz
工作带宽	5.0-5.9	GHz
中心损耗	2.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-4.2GHz	dBc
带外抑制	35@6.8-12.0GHz	dBc

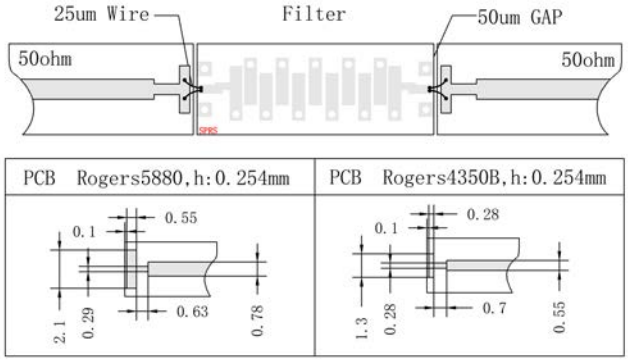
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：6.0，h：0.26

外形图：端口居中



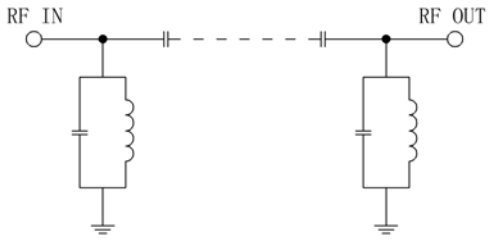
推荐装配图



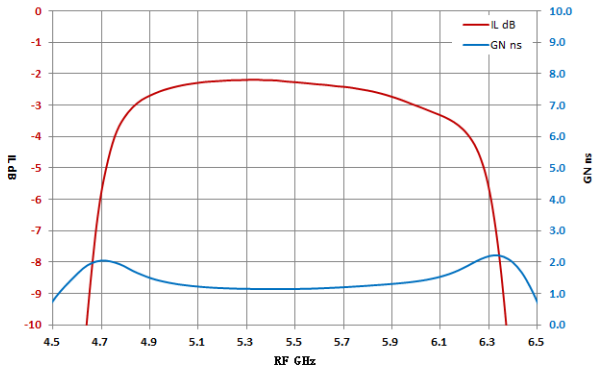
注意事项

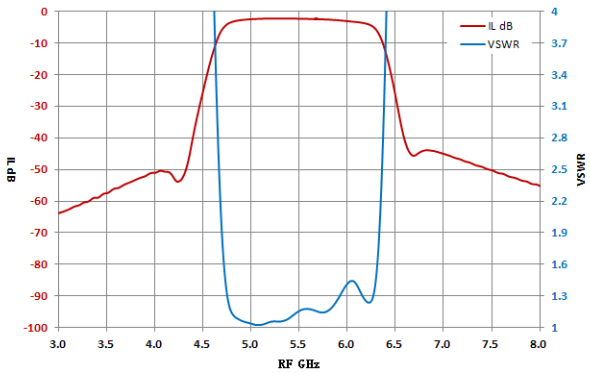
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

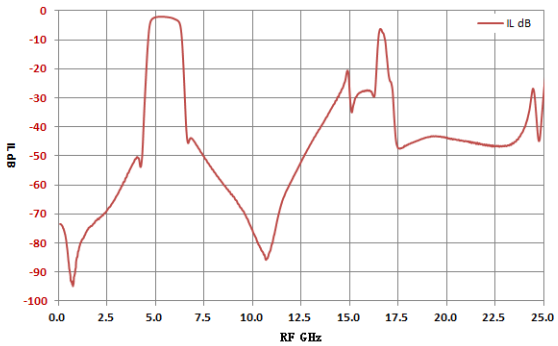
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



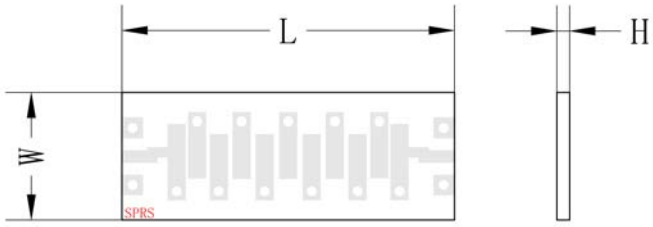
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	5.5	GHz
工作带宽	5.0-6.0	GHz
中心损耗	3.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-4.1GHz	dBc
带外抑制	40@7.1-13.0GHz	dBc

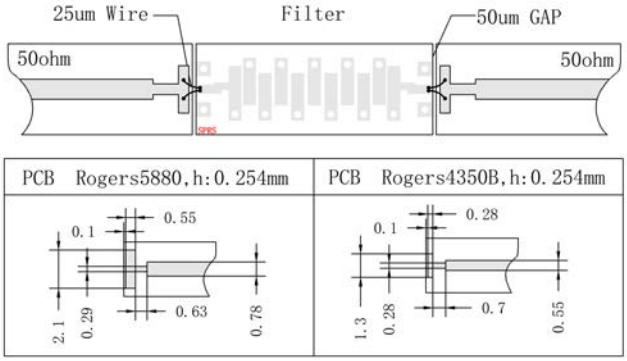
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：6.0，h：0.26

外形图：端口居中



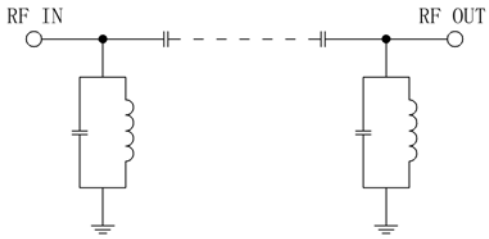
推荐装配图



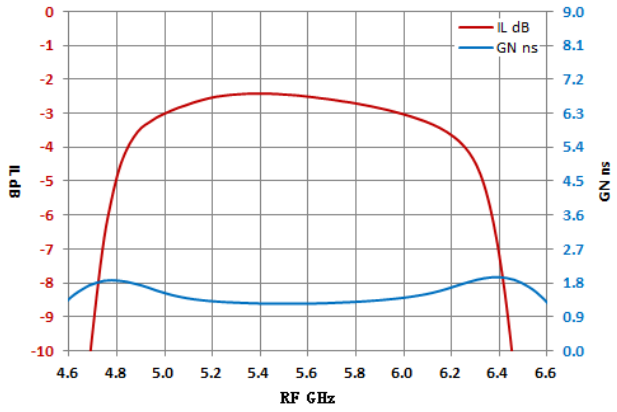
注意事项

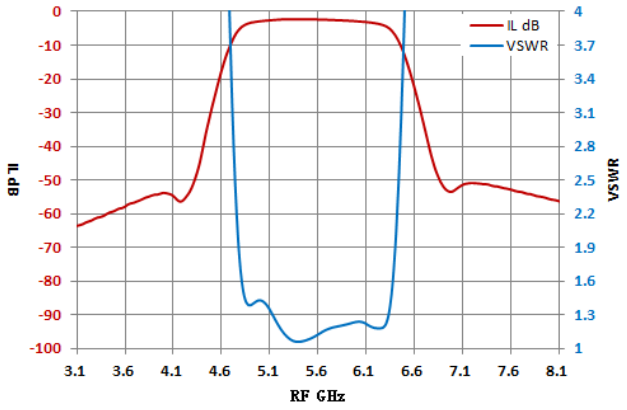
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

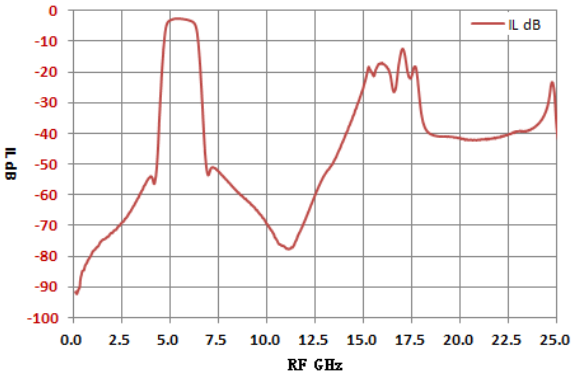
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

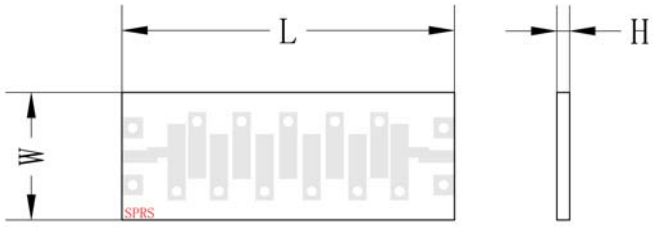
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	5.5	GHz
工作带宽	5.0-6.0	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-4.2GHz	dBc
带外抑制	40@6.9-13.0GHz	dBc

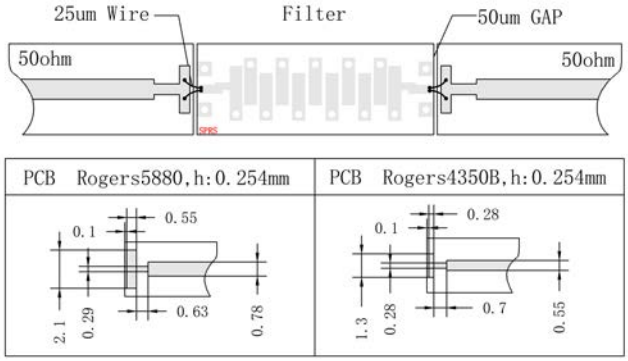
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：5.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



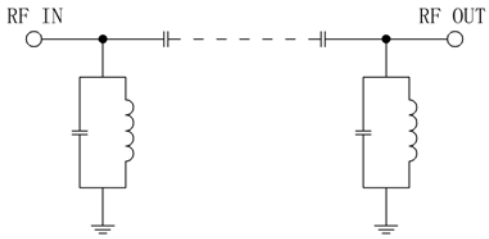
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

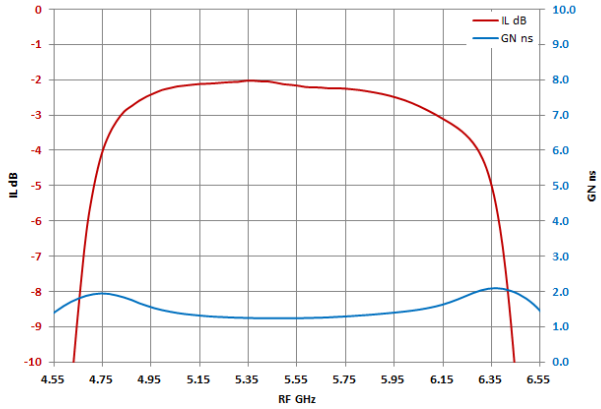
参考实物图

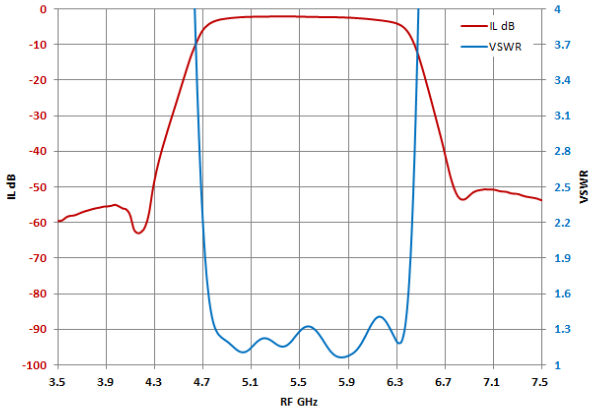


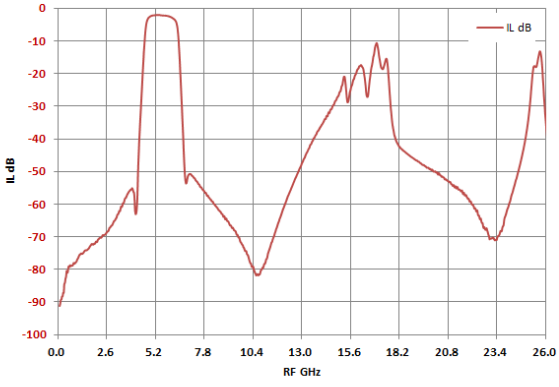
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



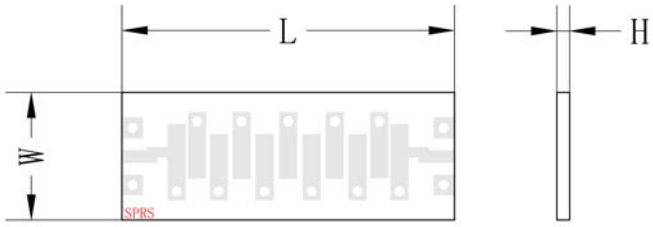
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	5.8	GHz
工作带宽	5.0-6.5	GHz
中心损耗	2.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.8	ns
带外抑制	40@DC-3.8GHz	dBc
带外抑制	40@8.0-13.0GHz	dBc

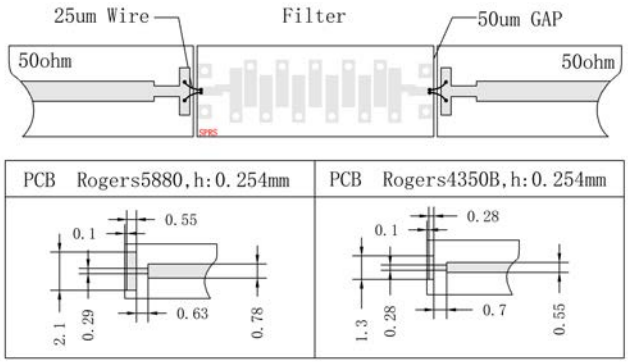
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：5.5，h：0.26

外形图：端口居中



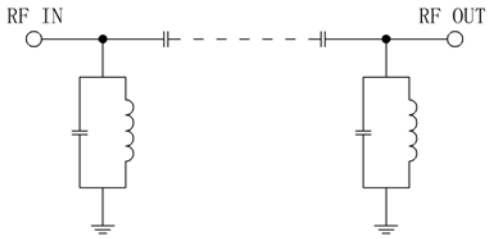
推荐装配图



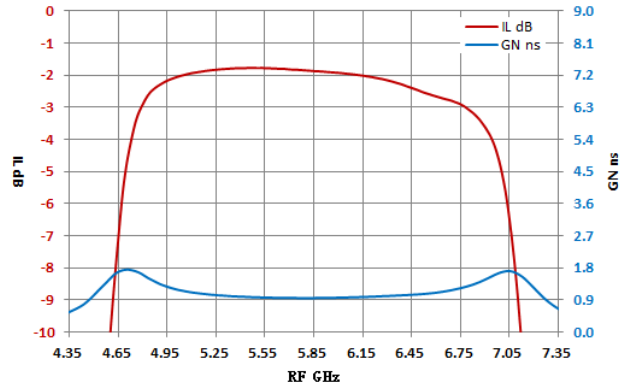
注意事项

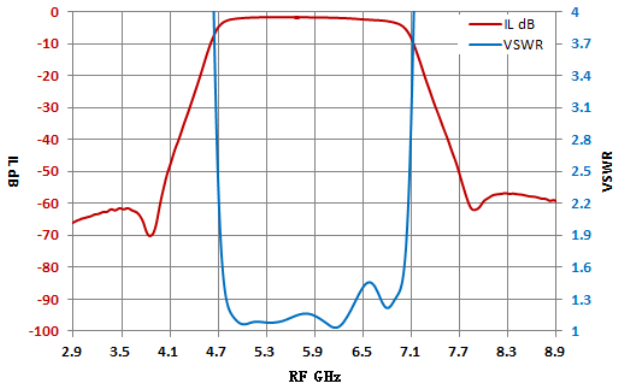
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

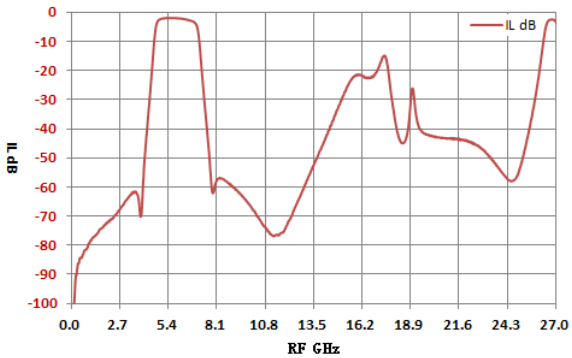
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

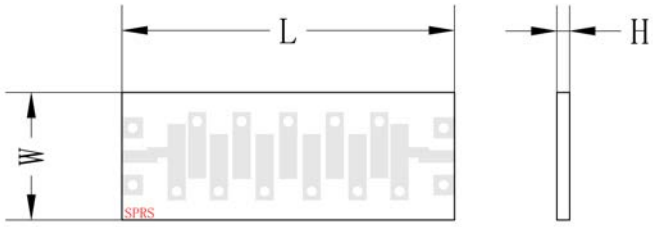
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	6.05	GHz
工作带宽	5.0-7.1	GHz
中心损耗	2.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-4.1GHz	dBc
带外抑制	40@8.6-13.0GHz	dBc

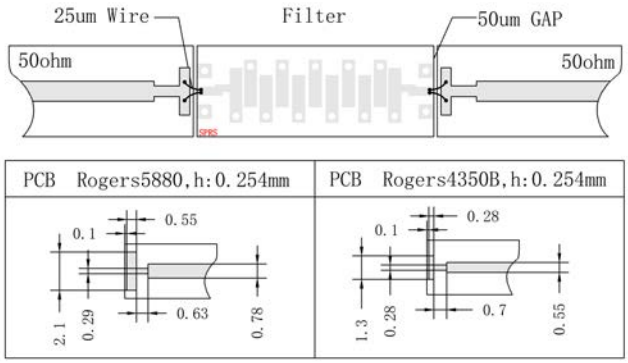
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：5.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



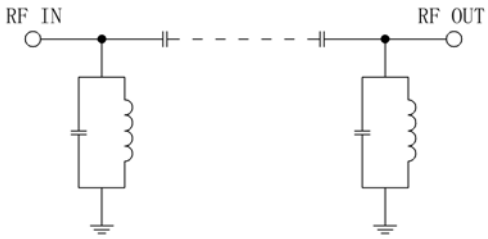
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

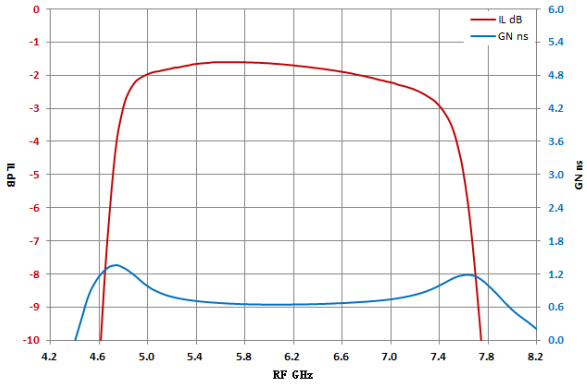
参考实物图

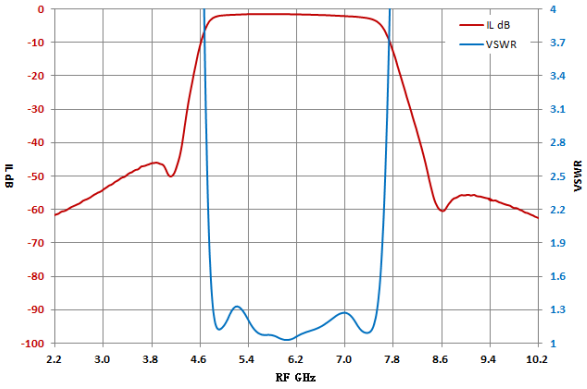


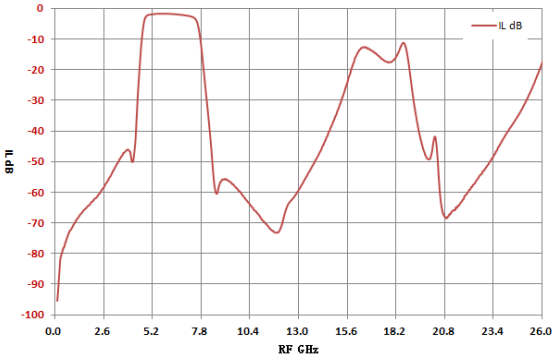
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



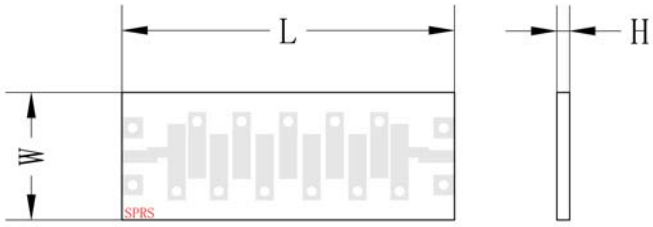
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	6.2	GHz
工作带宽	5.0-7.4	GHz
中心损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-3.5GHz	dBc
带外抑制	40@9.1-14.0GHz	dBc

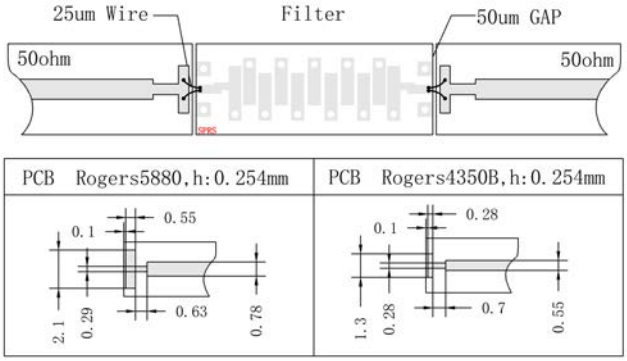
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：5.0，h：0.26

外形图：端口居中



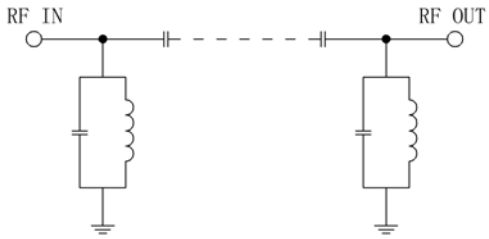
推荐装配图



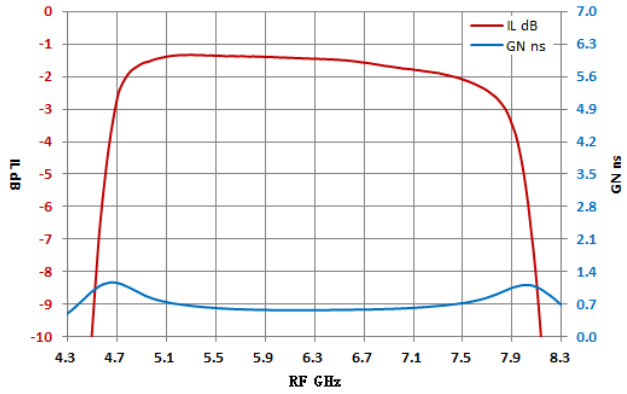
注意事项

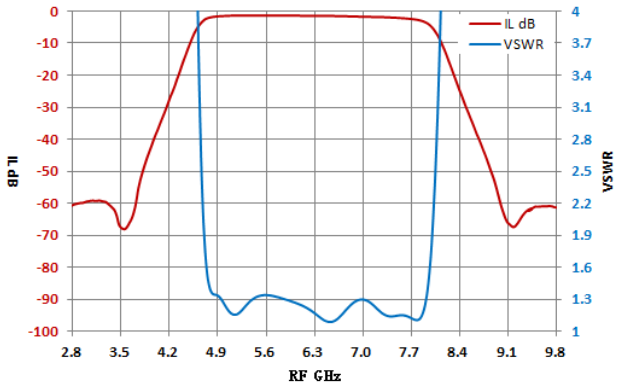
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

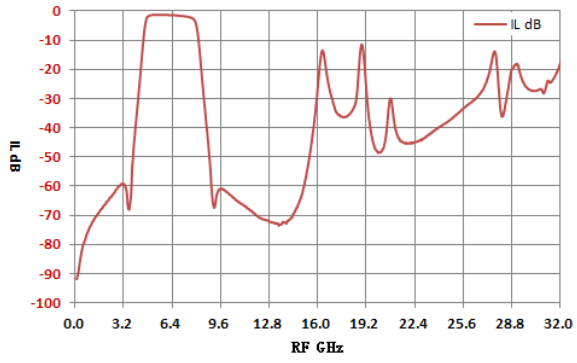
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

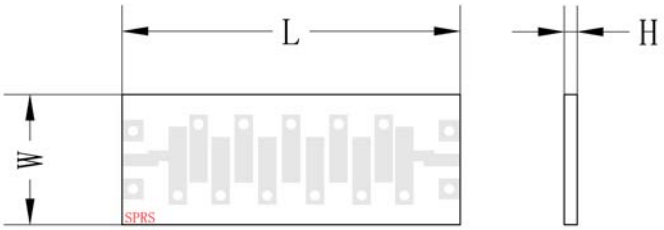
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	5.5	GHz
工作带宽	5.2-5.8	GHz
中心损耗	2.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.6	ns
带外抑制	35@DC-4.5GHz	dBc
带外抑制	35@6.7-11.0GHz	dBc

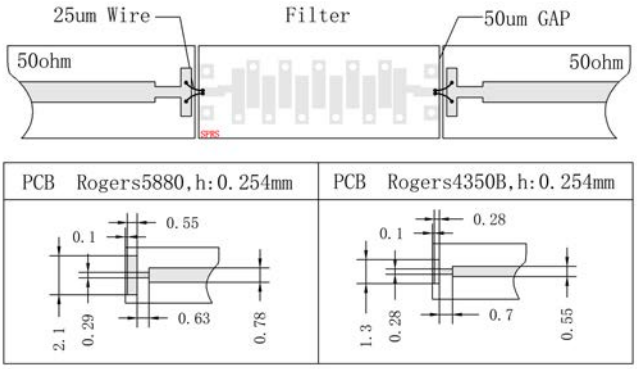
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：7.0，W：6.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

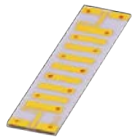
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

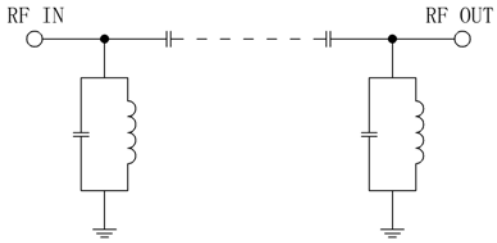
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

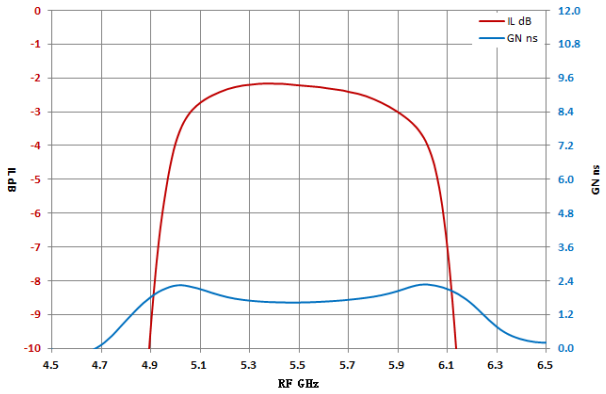
参考图

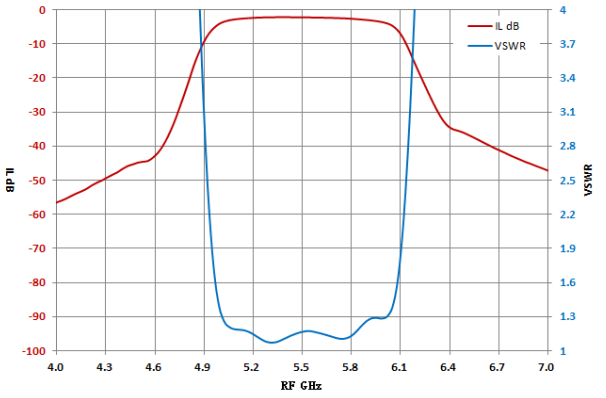


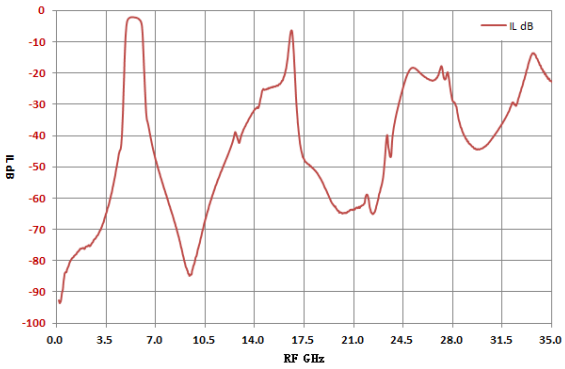
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



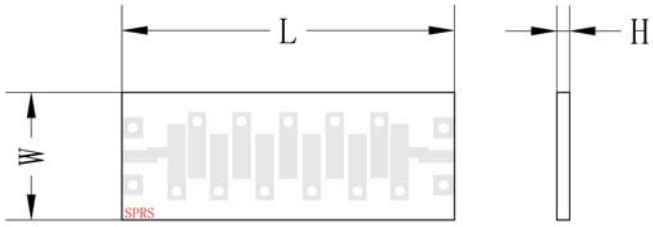
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	6.6	GHz
工作带宽	5.2-8.0	GHz
中心损耗	2.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-3.5GHz	dBc
带外抑制	40@10.4-15.0GHz	dBc

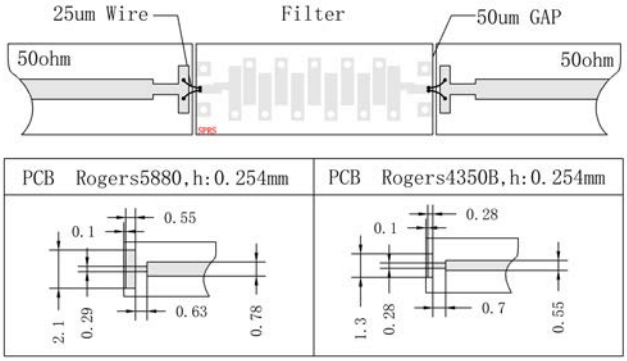
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：5.0，h：0.26

外形图：端口居中



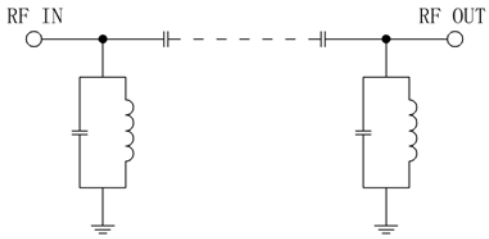
推荐装配图



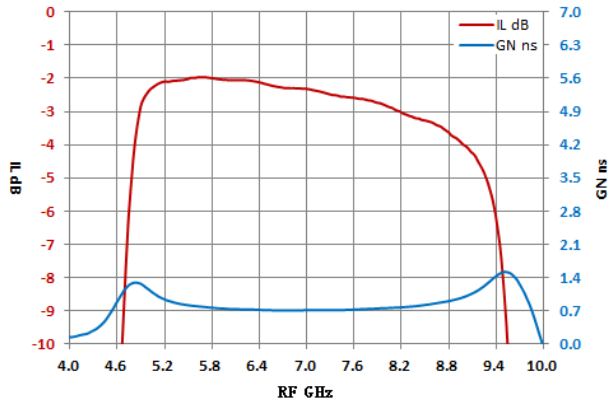
注意事项

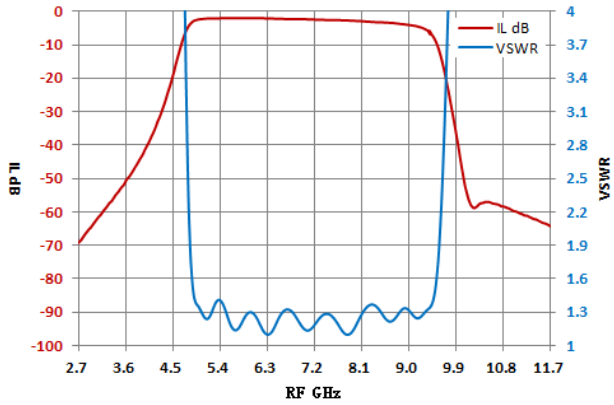
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

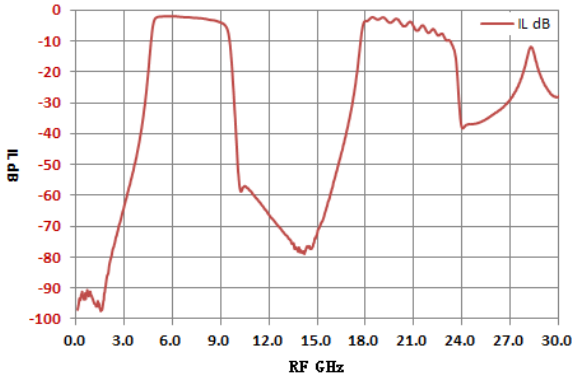
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

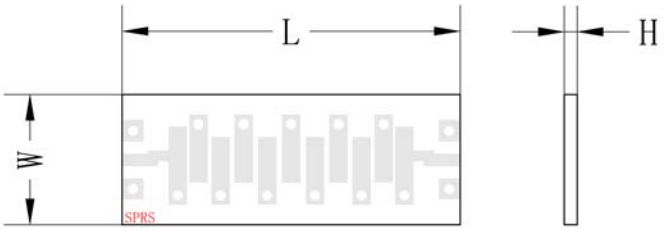
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	5.55	GHz
工作带宽	5.3-5.8	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-4.7GHz	dBc
带外抑制	40@6.5-13.0GHz	dBc

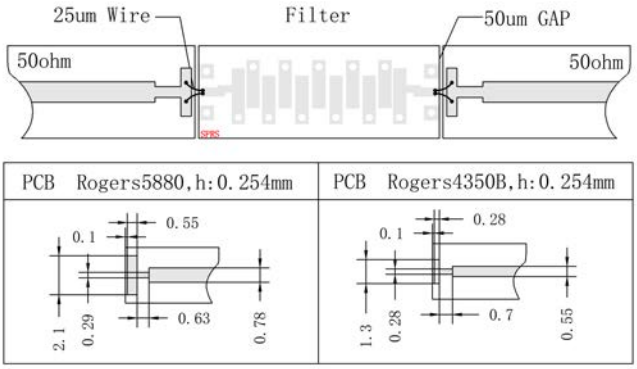
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：8.0，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

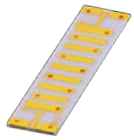
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

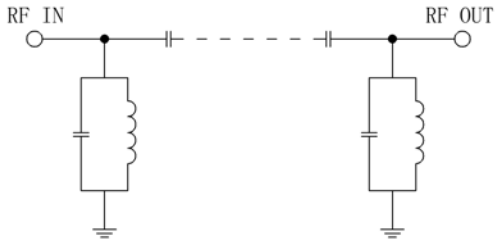
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

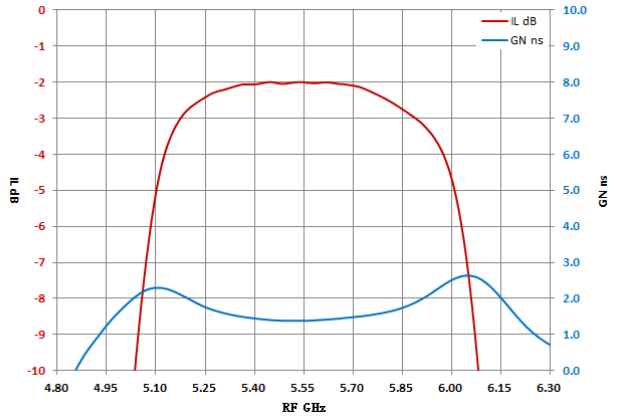
参考图

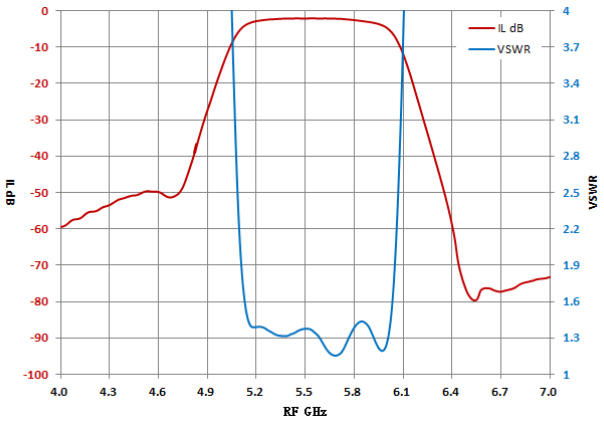


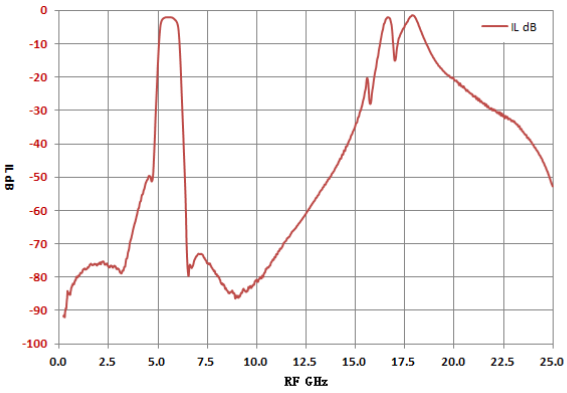
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



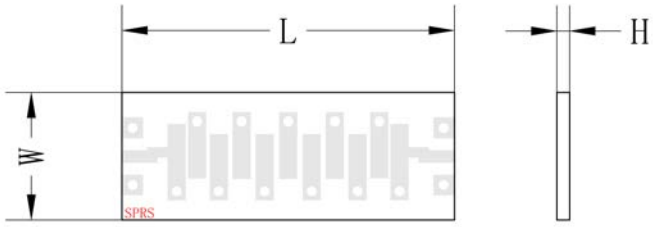
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	5.8	GHz
工作带宽	5.3-6.2	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-4.4GHz	dBc
带外抑制	38@7.0-12.0GHz	dBc

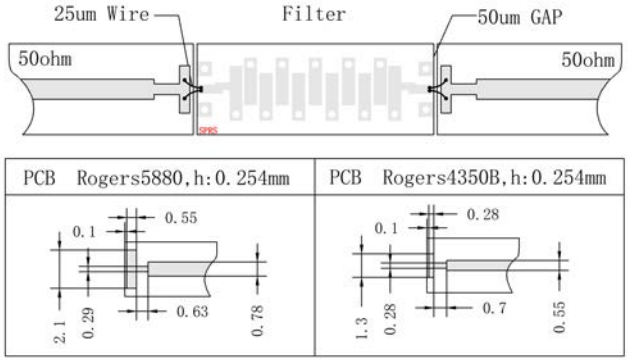
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：5.5，h：0.26

外形图：端口居中



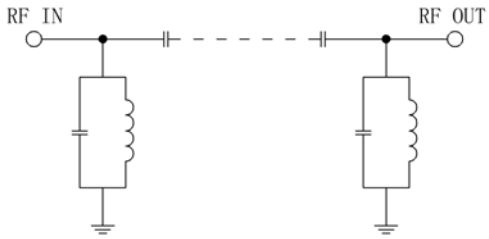
推荐装配图



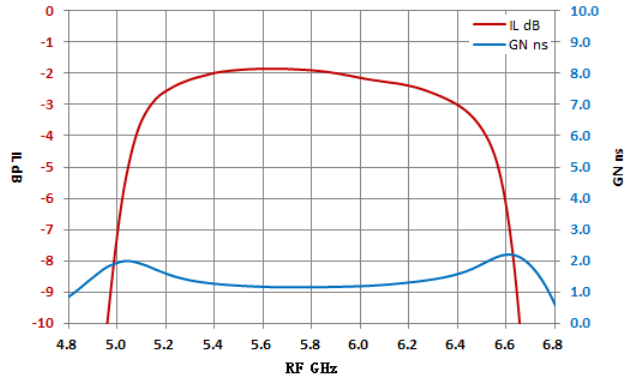
注意事项

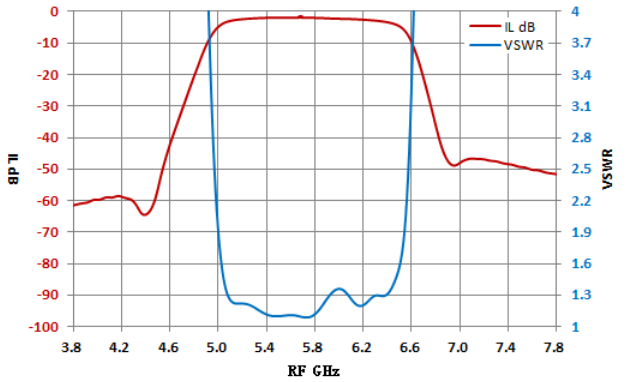
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

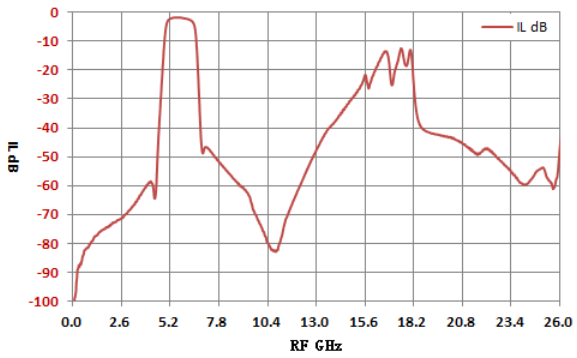
原理图



典型曲线







产品特点

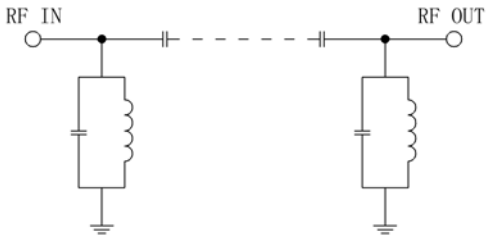
高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



技术要求

项目	参数	单位
中心频率	5.4	GHz
工作带宽	0	GHz
中心损耗	6.1	dB
带内波动	0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0	ns
带外抑制	35@DC-4.9GHz	dBc
带外抑制	40@6.0-13.0GHz	dBc

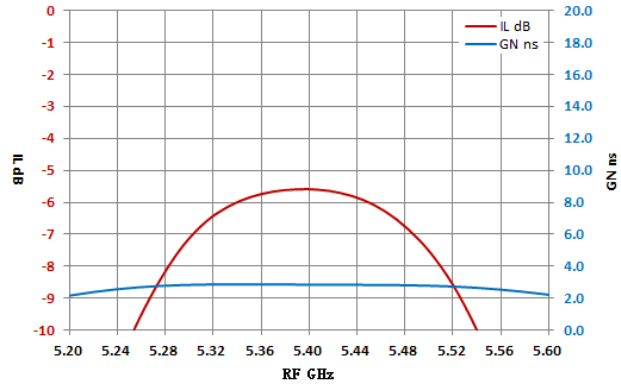
原理图

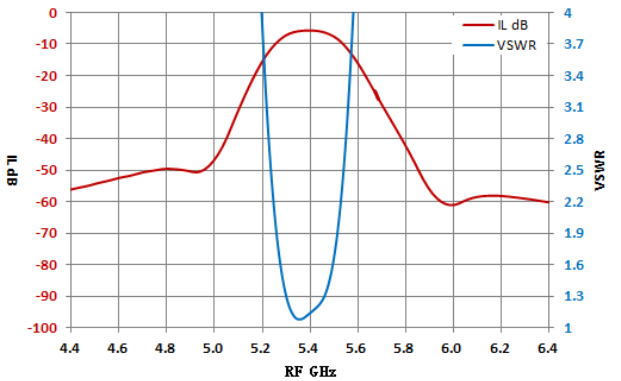


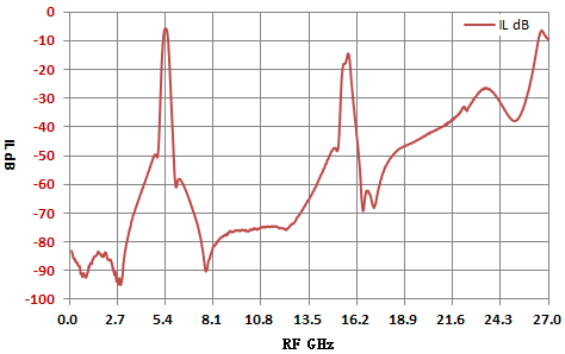
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：4.0，h：0.39

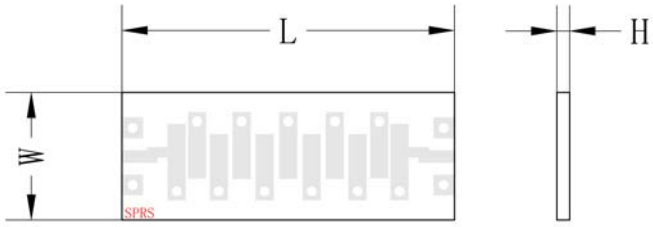
典型曲线



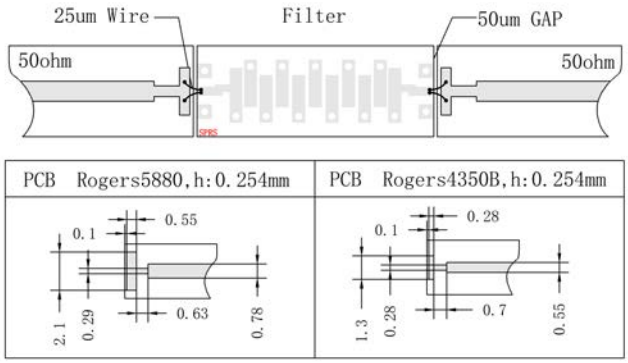




外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.62mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

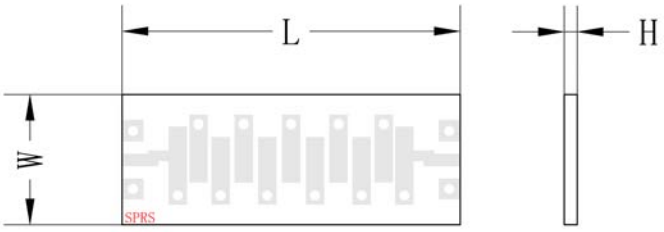
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	5.5	GHz
中心损耗	4.5	dB
驻波比	1.7:1	
带外抑制	40@DC-4.9GHz	dBc
带外抑制	35@6.1-14.0GHz	dBc

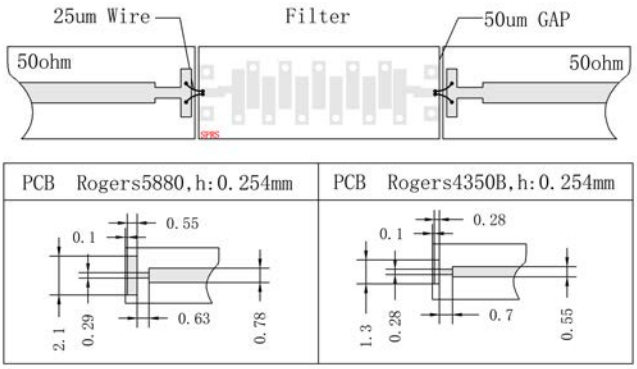
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：7.0，W：4.0，h：0.39

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.61mm,端口可互换;

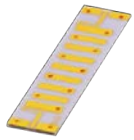
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

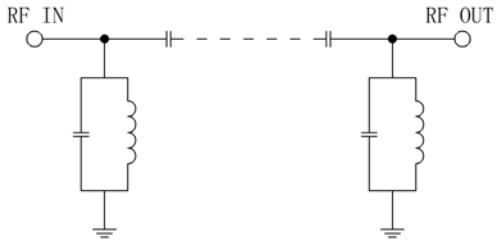
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

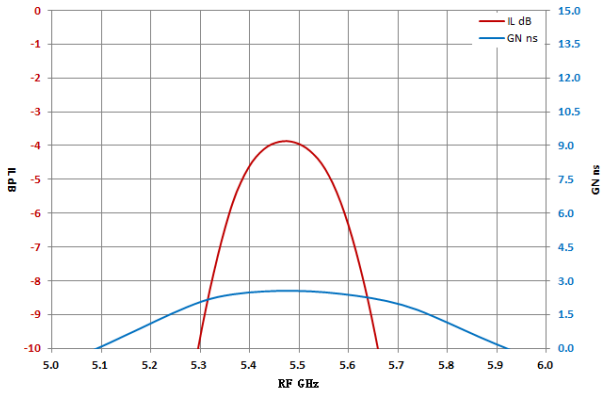
参考图

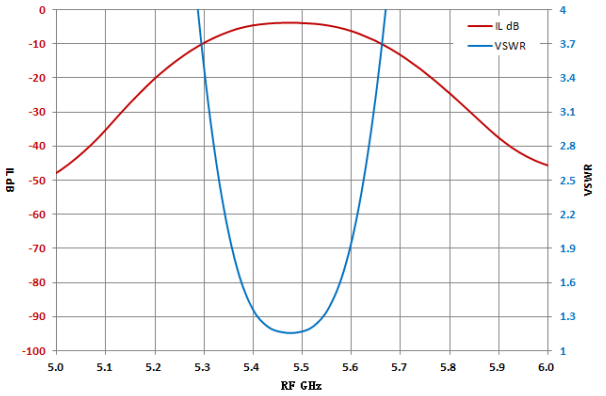


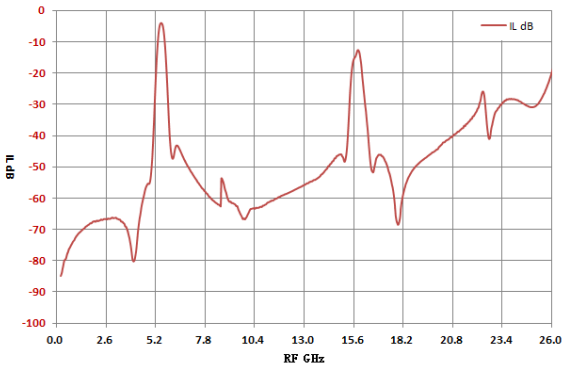
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

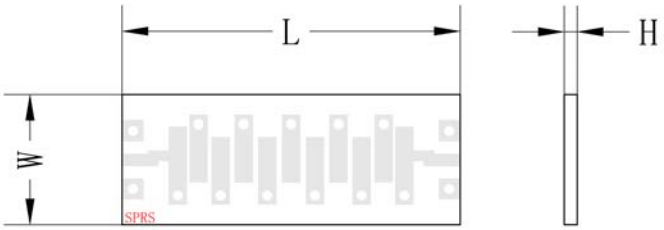
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	6.6	GHz
工作带宽	5.6-7.6	GHz
中心损耗	1.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	1.0	ns
带外抑制	50@DC-4.5GHz	dBc
带外抑制	40@8.7-15.0GHz	dBc

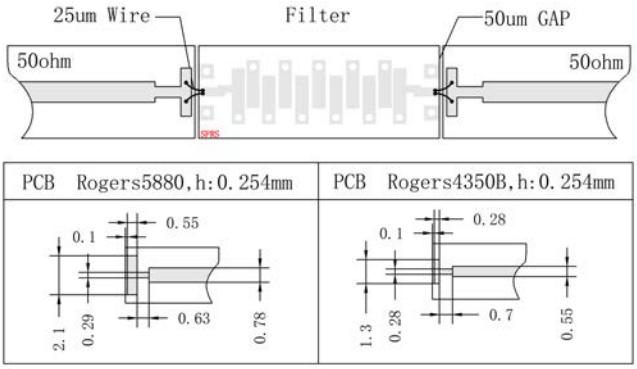
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：6.5，W：5.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

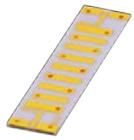
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

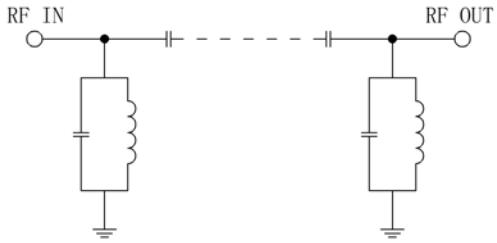
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

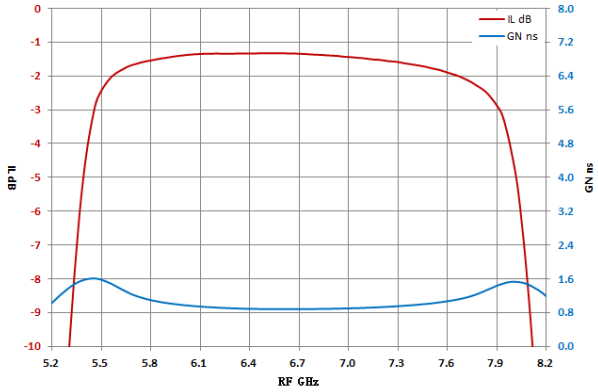
参考图

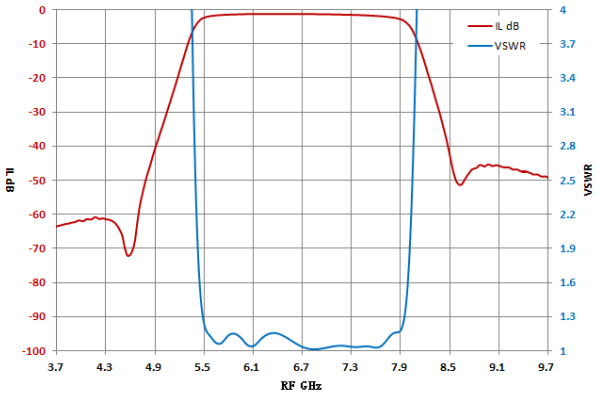


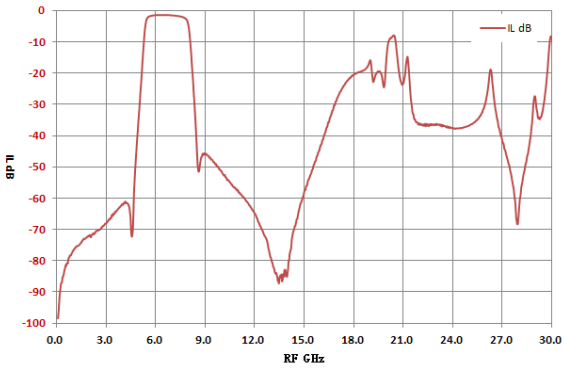
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



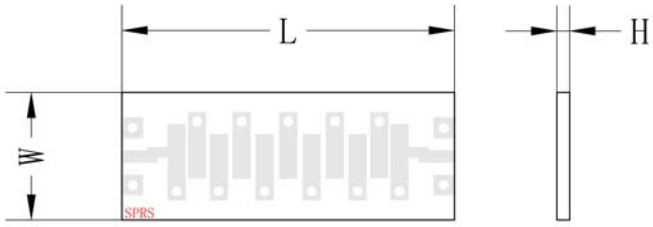
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	7.0	GHz
工作带宽	5.7-8.3	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-4.5GHz	dBc
带外抑制	40@9.9-15.0GHz	dBc

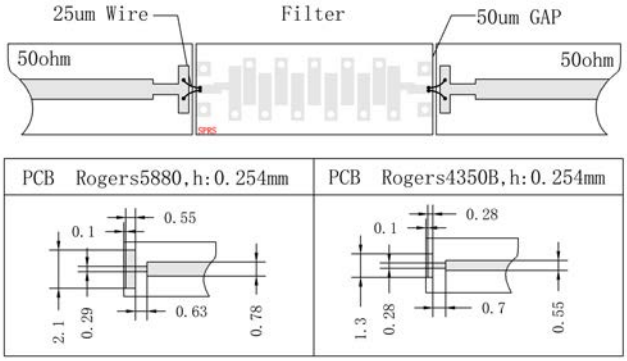
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：4.9，h：0.26

外形图：端口居中



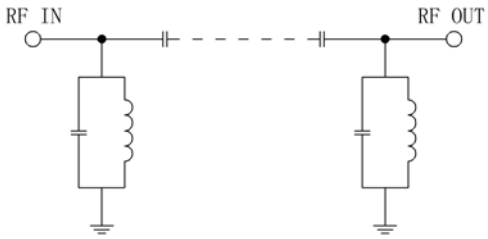
推荐装配图



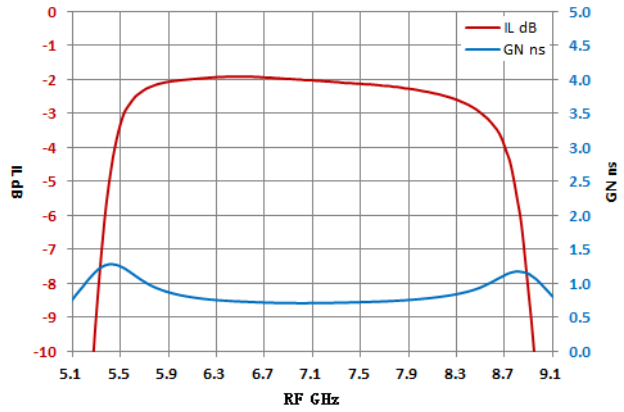
注意事项

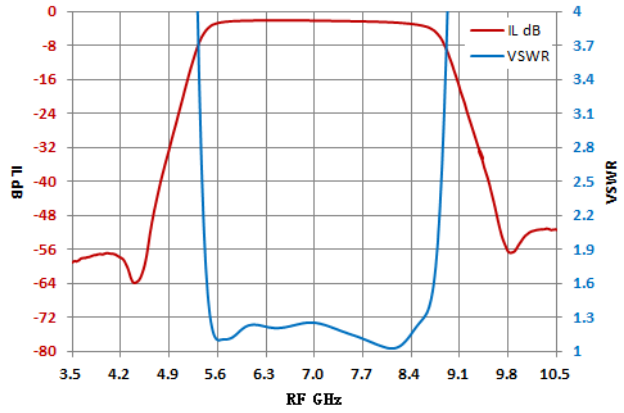
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

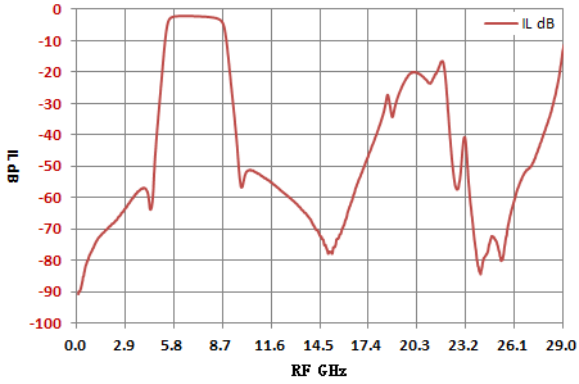
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

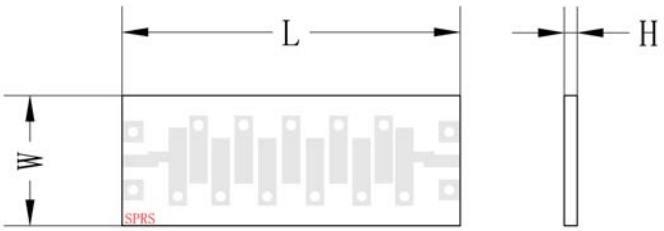
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	7.85	GHz
工作带宽	5.7-10.0	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	2.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	50@DC-4.3GHz	dBc
带外抑制	50@11.8-19.0GHz	dBc

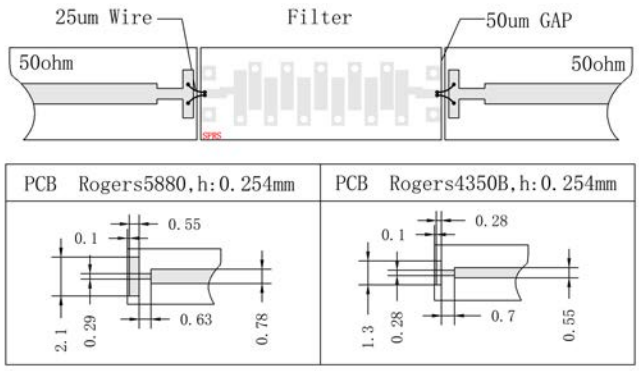
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：7.5，W：4.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

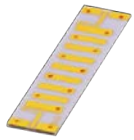
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

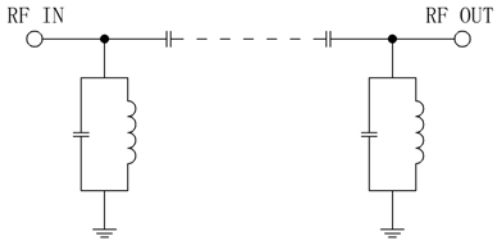
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

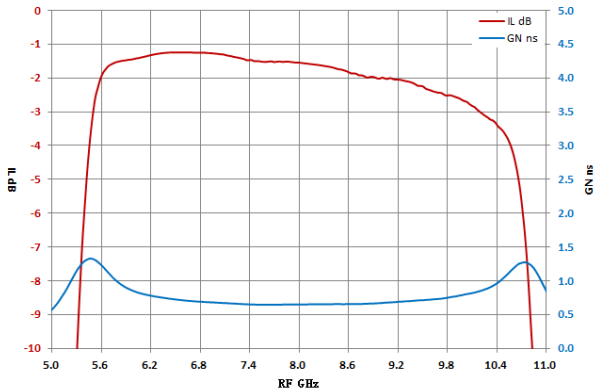
参考图

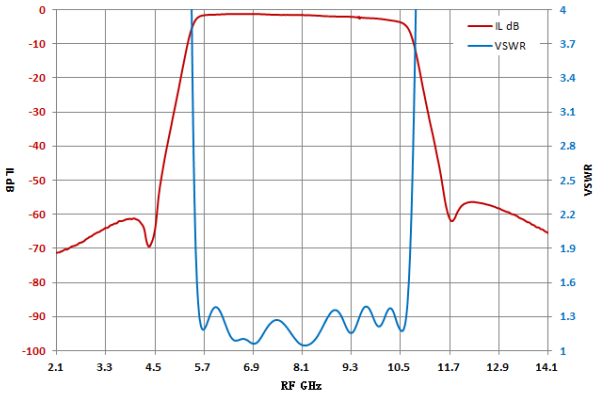


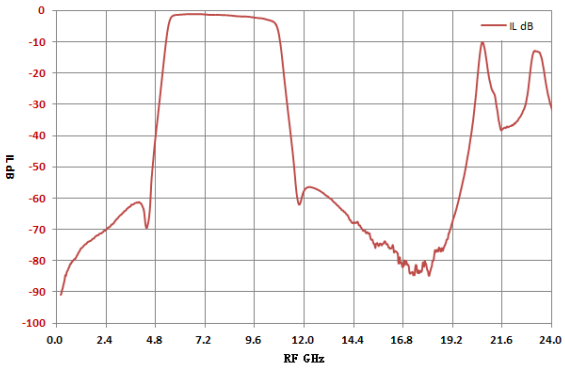
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



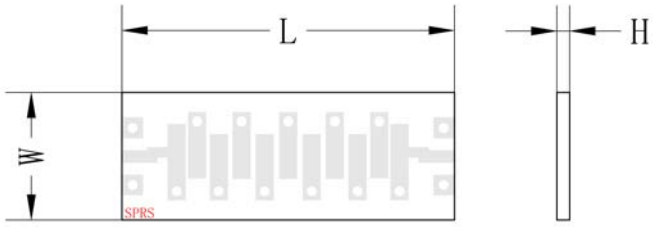
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	6.2	GHz
工作带宽	5.8-6.5	GHz
中心损耗	2.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-5.0GHz	dBc
带外抑制	30@7.3-13.0GHz	dBc

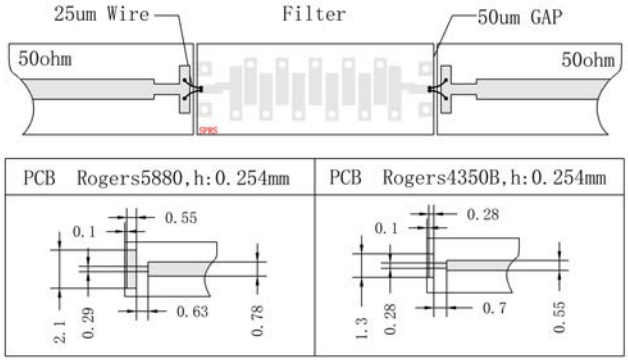
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：5.5，h：0.26

外形图：端口居中



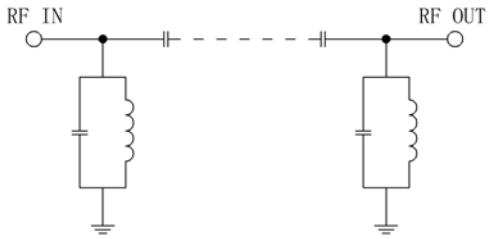
推荐装配图



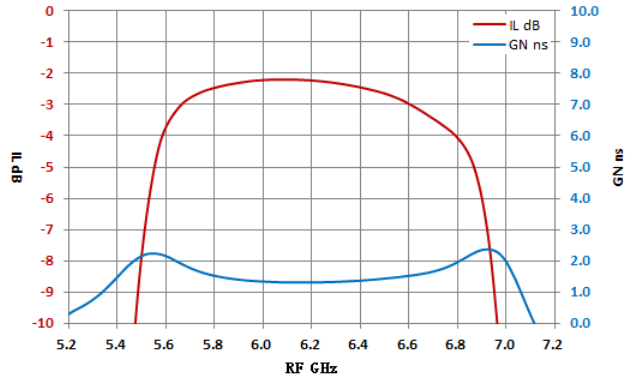
注意事项

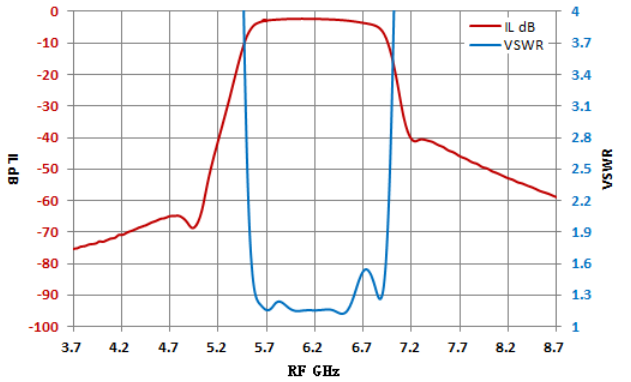
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

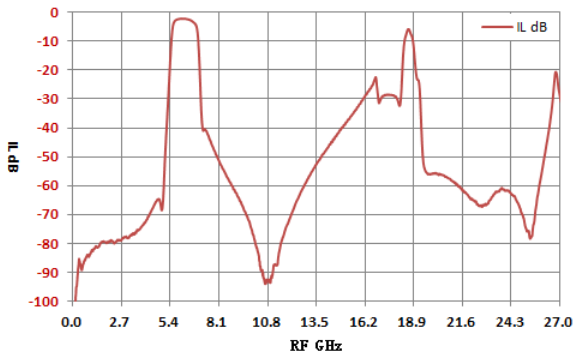
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



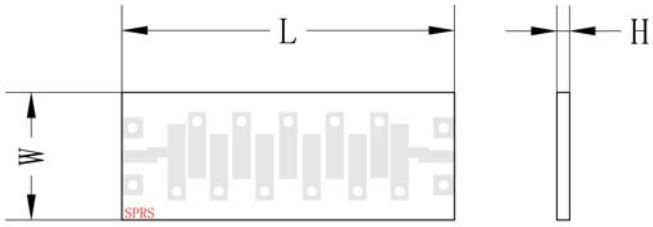
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	7.7	GHz
工作带宽	5.8-9.6	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	1.0	ns
带外抑制	40@DC-2.2GHz	dBc
带外抑制	35@12.2-17.0GHz	dBc

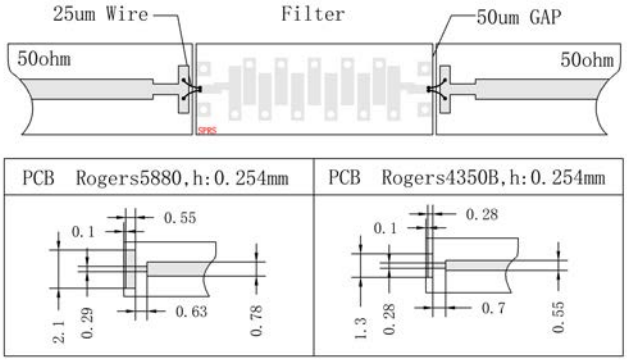
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



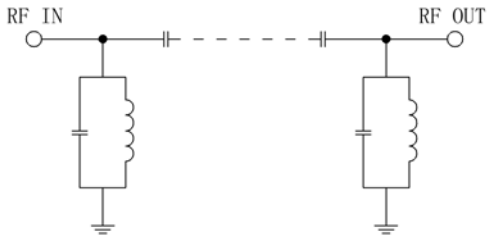
推荐装配图



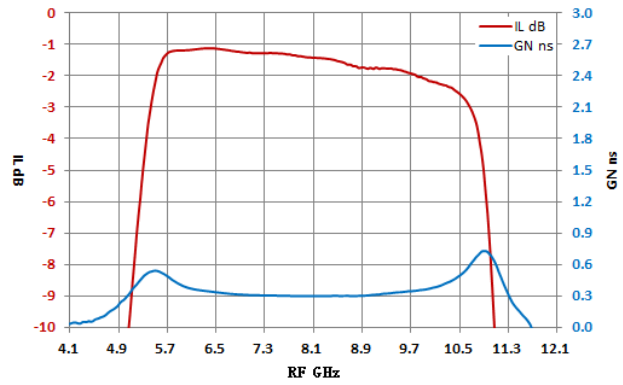
注意事项

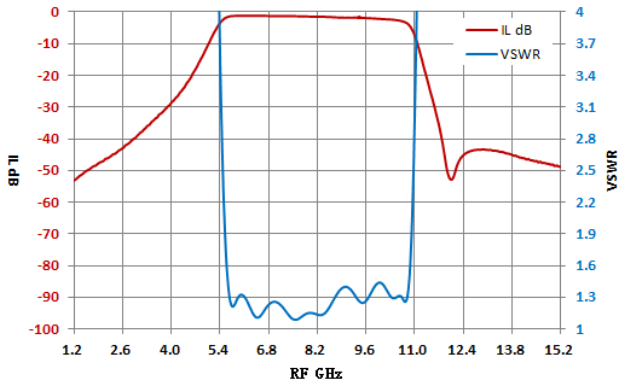
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

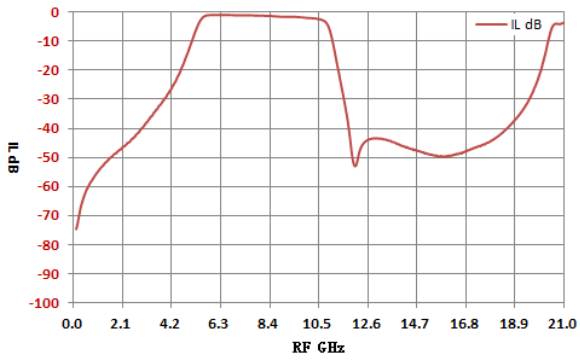
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



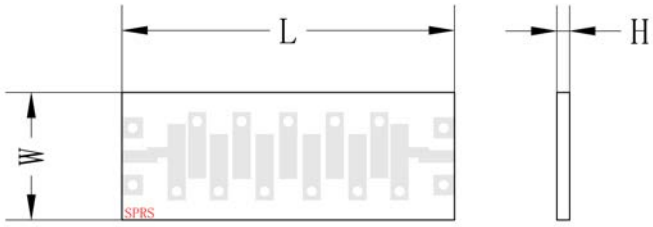
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	7.8	GHz
工作带宽	5.8-9.8	GHz
中心损耗	2.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	35@DC-4.2GHz	dBc
带外抑制	40@12.6-18.5GHz	dBc

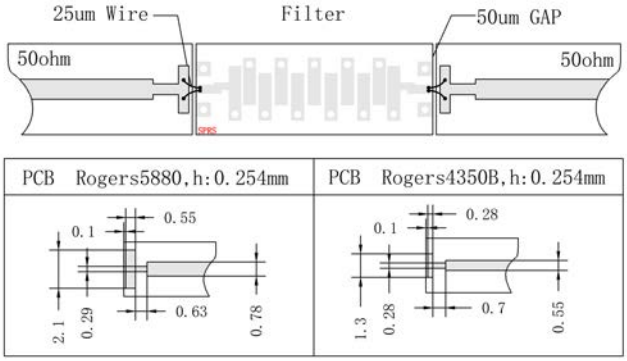
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：5.5，W：4.5，h：0.26

外形图：端口居中



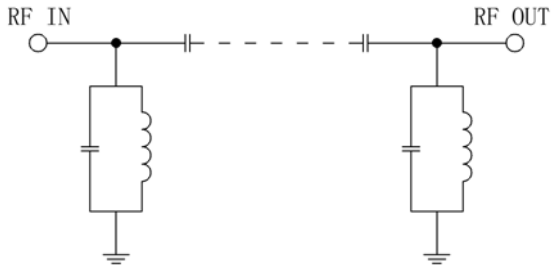
推荐装配图



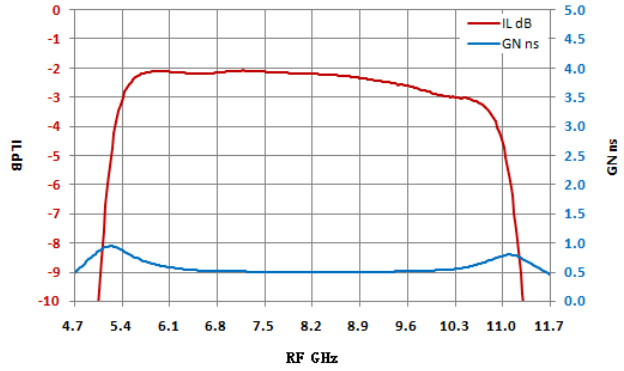
注意事项

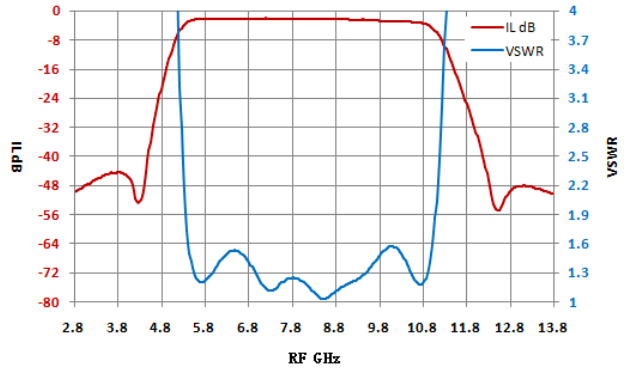
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

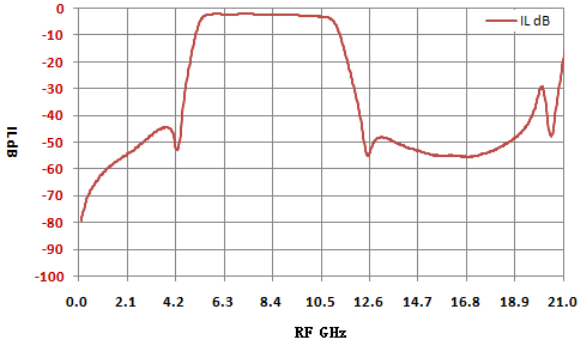
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



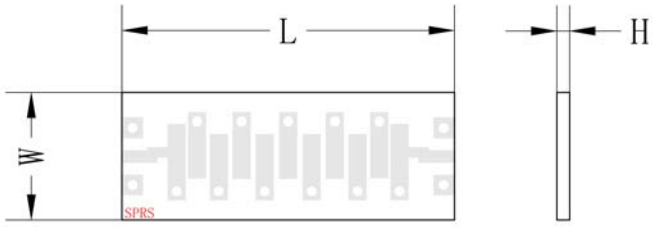
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	6.1	GHz
工作带宽	5.9-6.2	GHz
中心损耗	4.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	35@DC-5.4GHz	dBc
带外抑制	35@6.8-12.0GHz	dBc

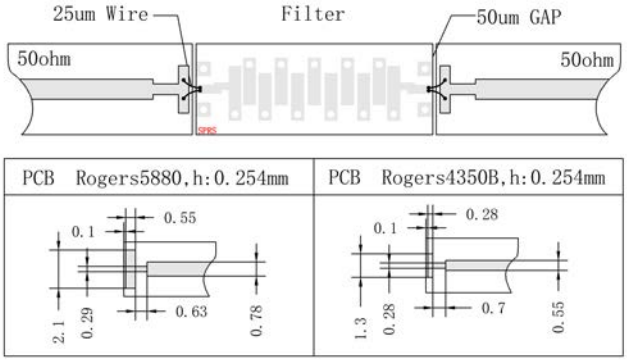
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：5.5，h：0.26

外形图：端口居中



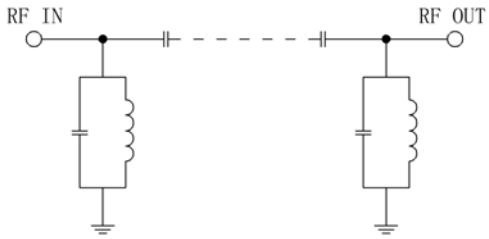
推荐装配图



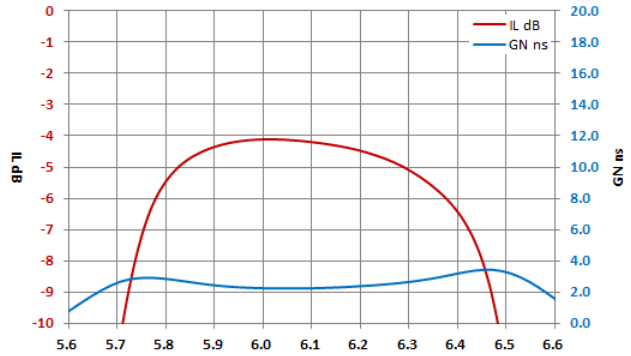
注意事项

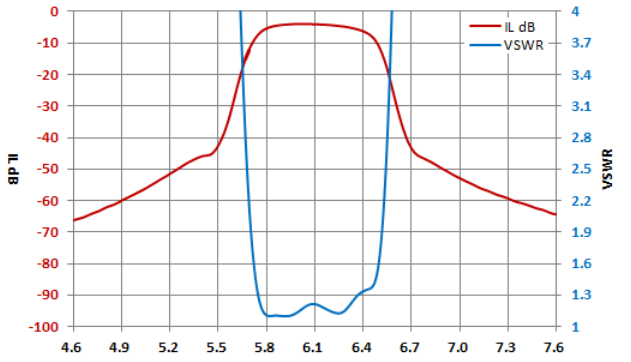
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

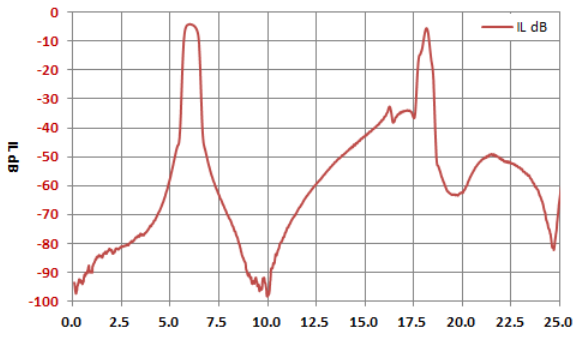
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



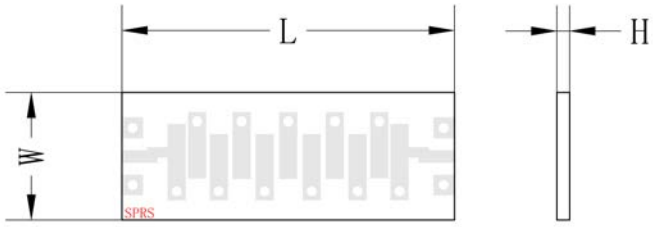
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	6.3	GHz
工作带宽	5.9-6.7	GHz
中心损耗	3.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	35@DC-5.2GHz	dBc
带外抑制	35@7.5-13.5GHz	dBc

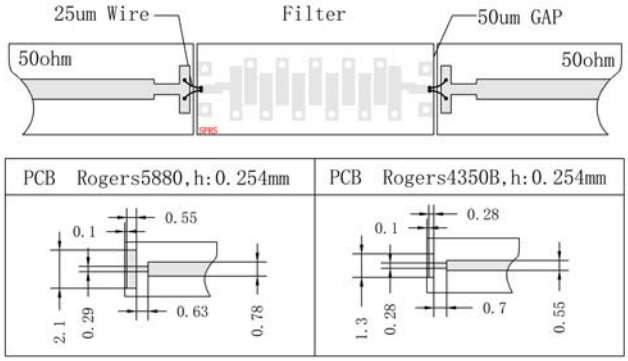
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：5.5，h：0.26

外形图：端口居中



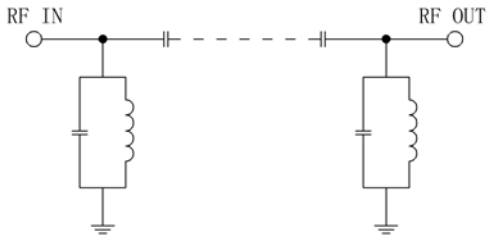
推荐装配图



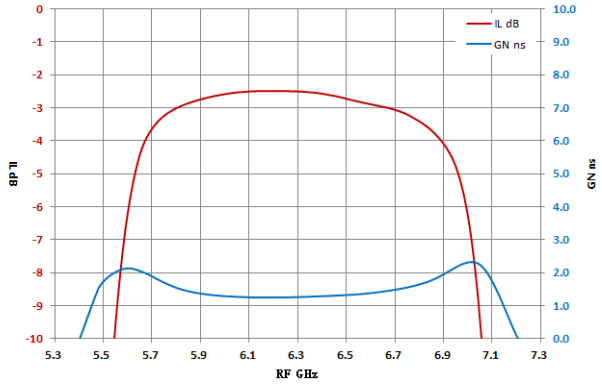
注意事项

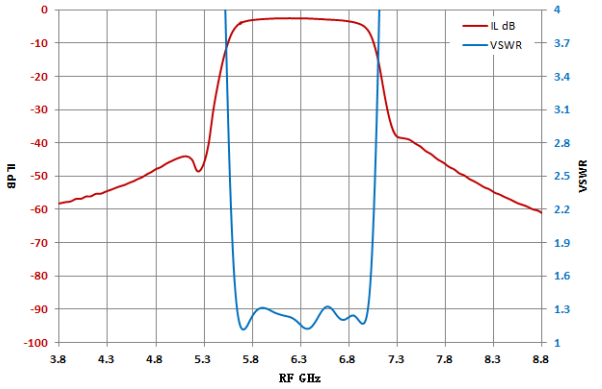
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

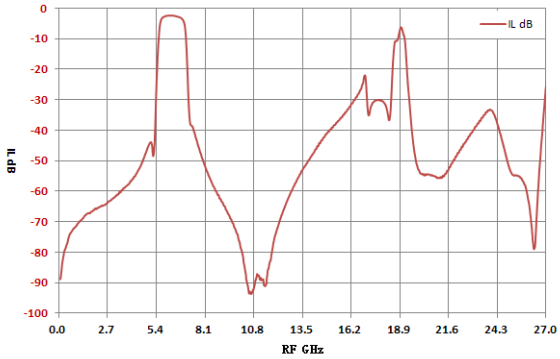
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



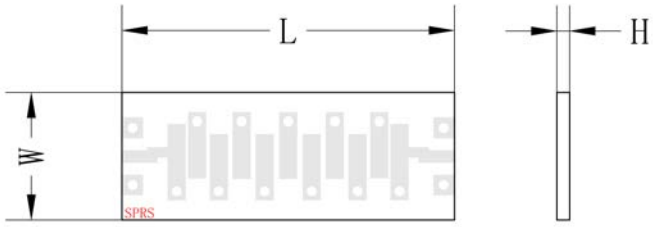
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	8.8	GHz
工作带宽	5.9-11.7	GHz
中心损耗	1.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-1.8GHz	dBc
带外抑制	30@16.0-18.0GHz	dBc

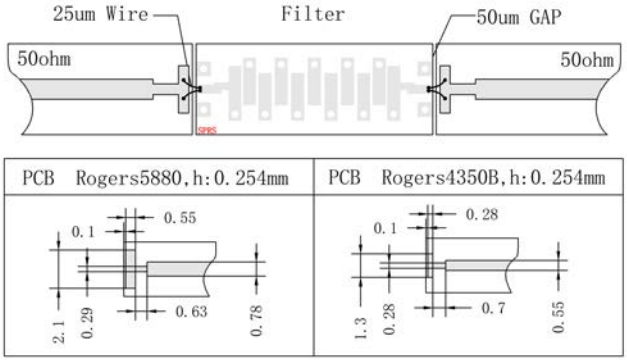
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：4.0，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



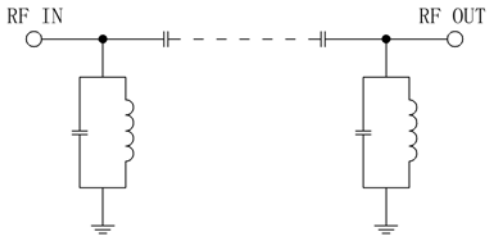
推荐装配图



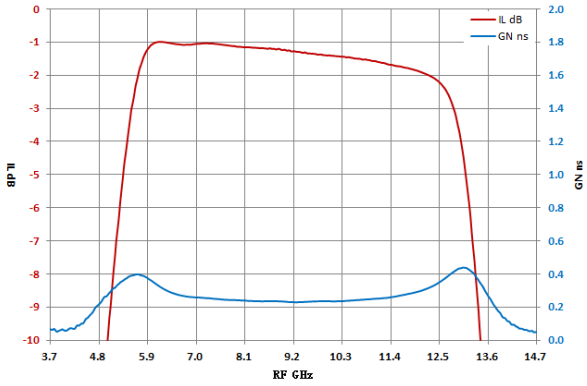
注意事项

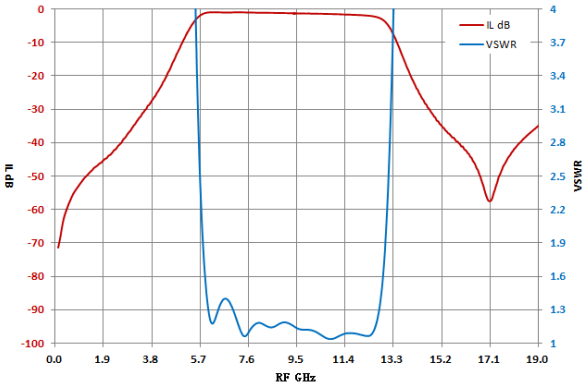
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

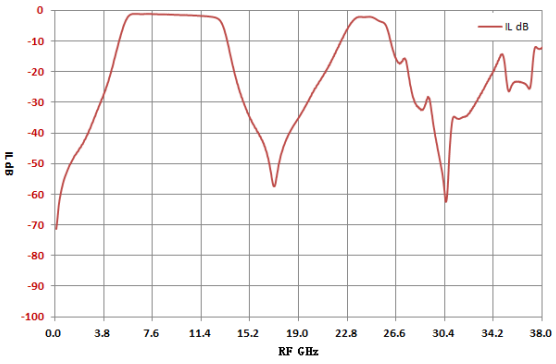
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



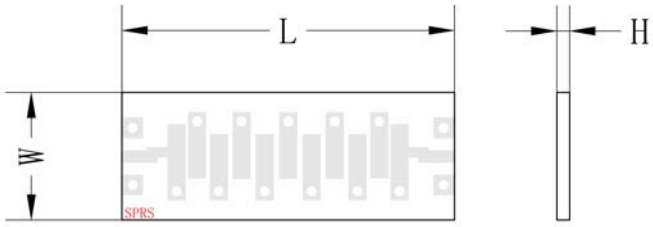
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	6.0	GHz
工作带宽	5.95-6.05	GHz
中心损耗	3.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-5.0GHz	dBc
带外抑制	40@7.0-15.0GHz	dBc

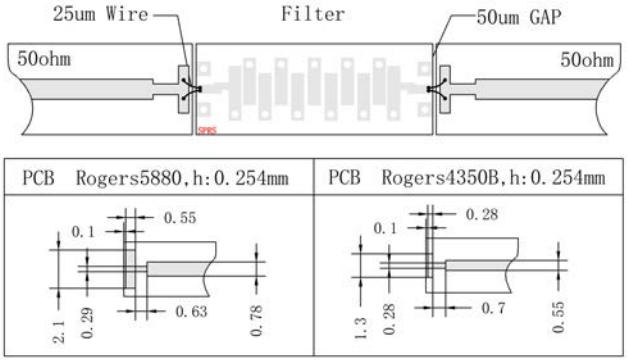
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



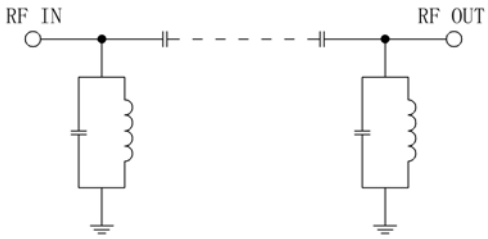
推荐装配图



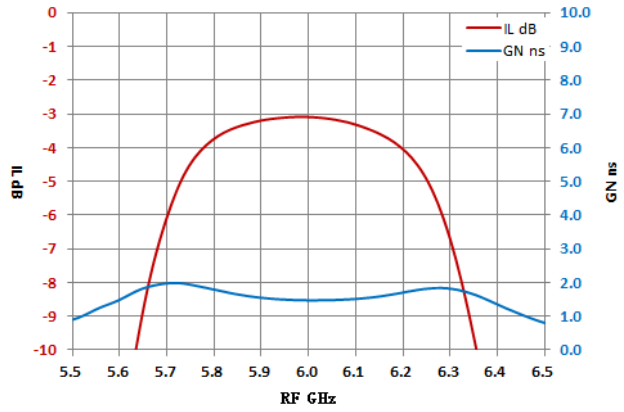
注意事项

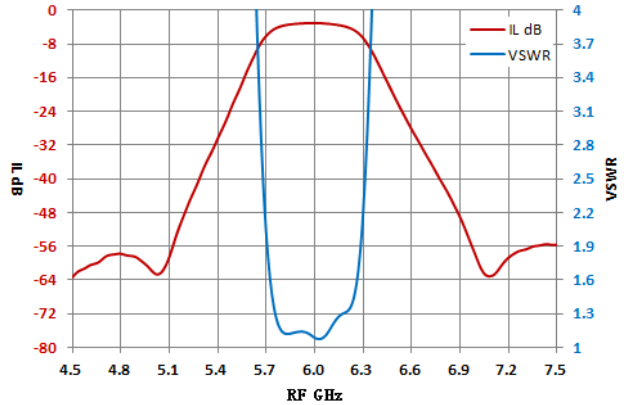
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

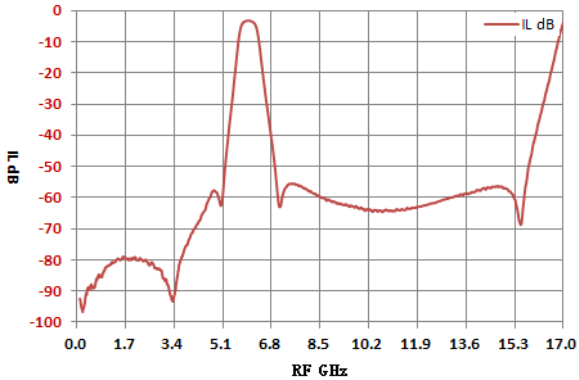
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



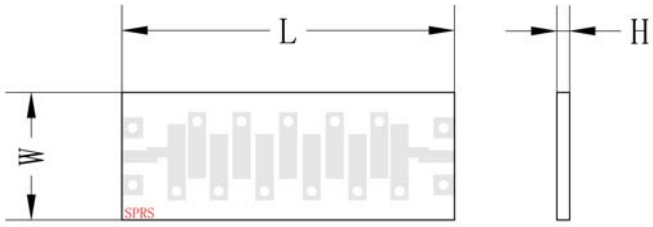
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	6.6	GHz
工作带宽	6.0-7.1	GHz
中心损耗	3.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	35@DC-5.1GHz	dBc
带外抑制	40@8.2-15.0GHz	dBc

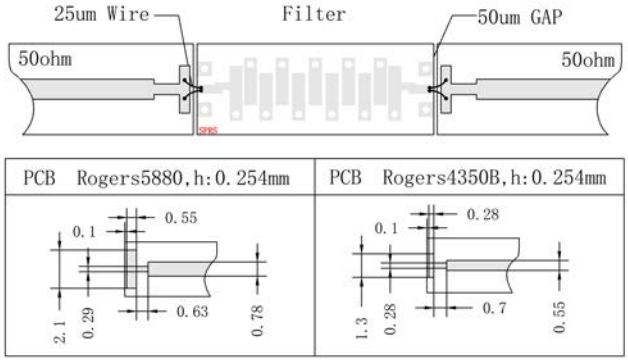
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：5.0，h：0.26

外形图：端口居中



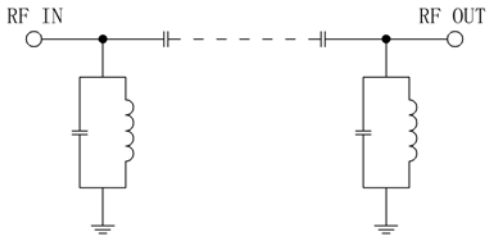
推荐装配图



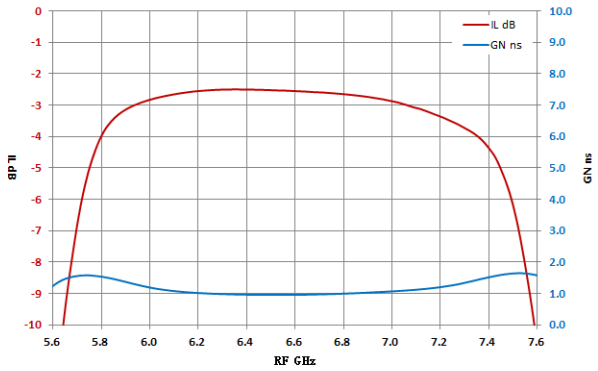
注意事项

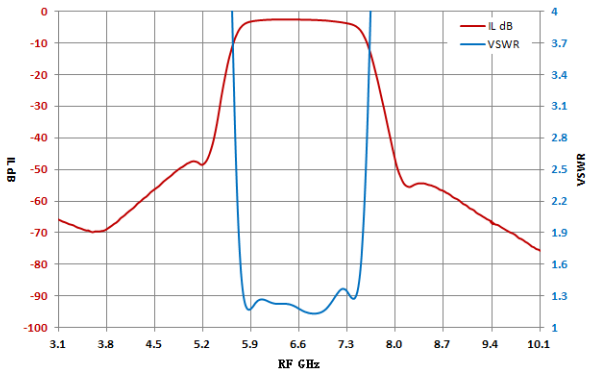
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

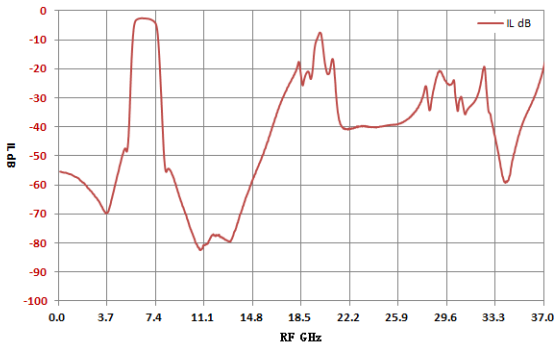
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



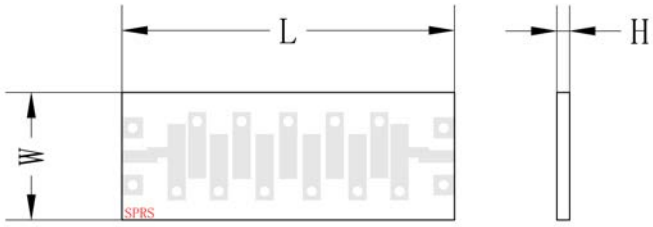
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	7.0	GHz
工作带宽	6.0-8.0	GHz
中心损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.6	ns
带外抑制	40@DC-4.9GHz	dBc
带外抑制	40@9.2-15.0GHz	dBc

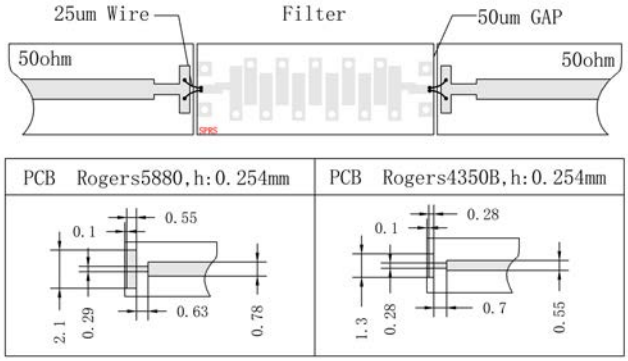
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：4.5，h：0.26

外形图：端口居中



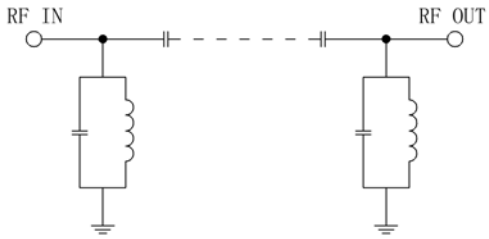
推荐装配图



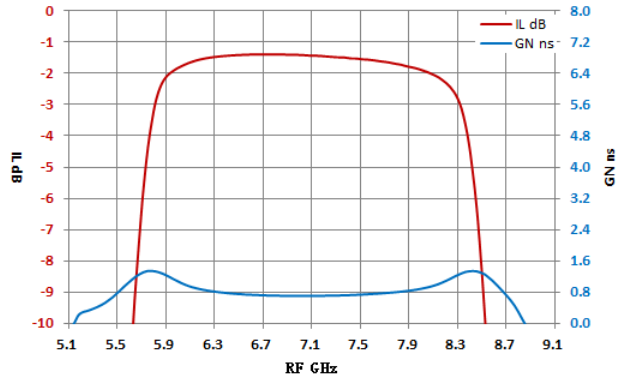
注意事项

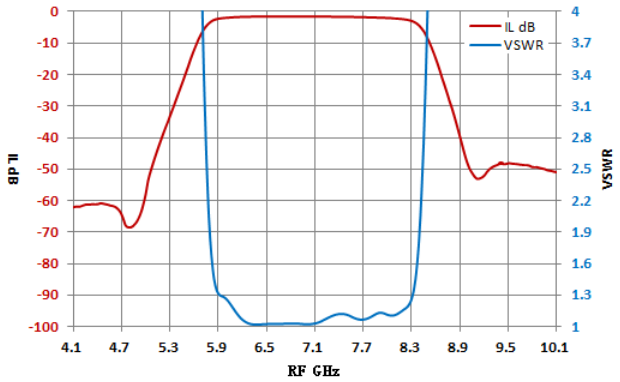
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

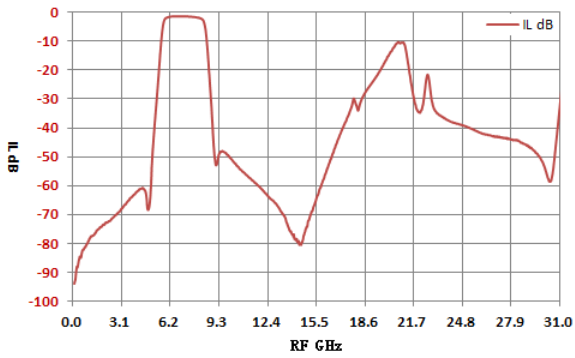
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



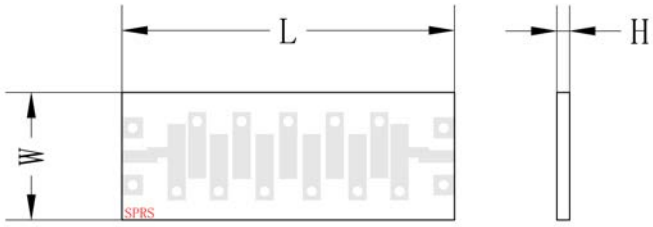
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	7.5	GHz
工作带宽	6.0-9.0	GHz
中心损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-4.7GHz	dBc
带外抑制	40@10.5-18.0GHz	dBc

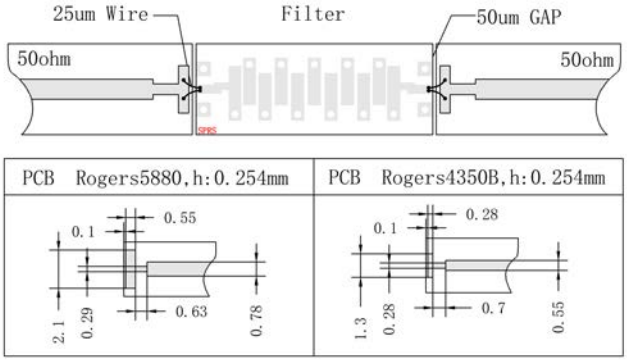
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：4.5，h：0.26

外形图：端口居中



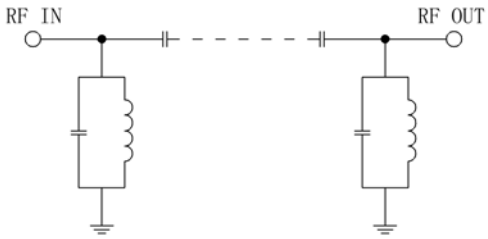
推荐装配图



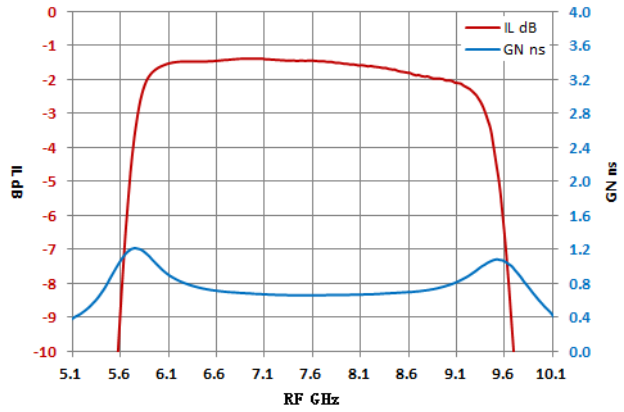
注意事项

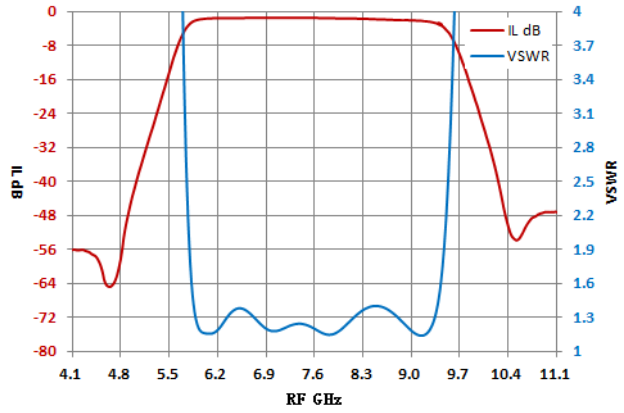
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

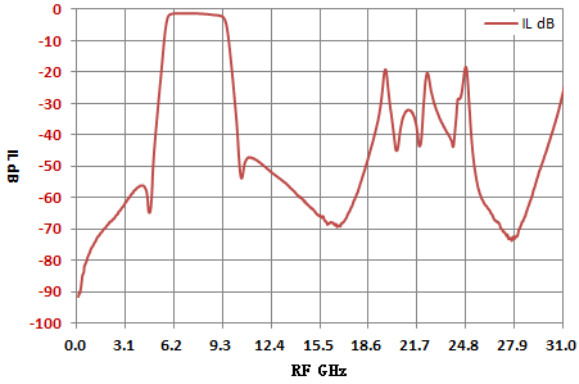
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

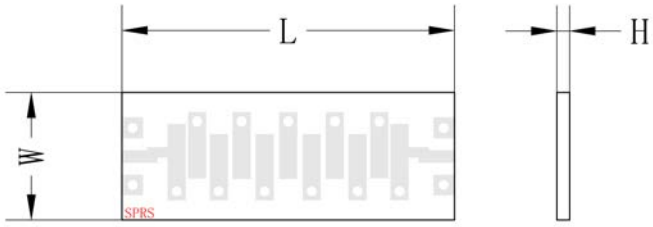
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	8.0	GHz
工作带宽	6.0-10.0	GHz
中心损耗	2.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-3.2GHz	dBc
带外抑制	40@13.0-17.0GHz	dBc

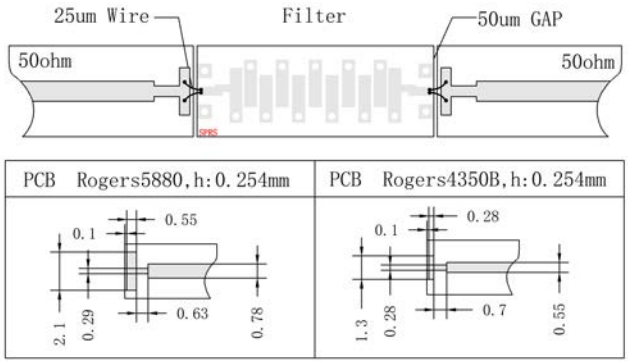
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



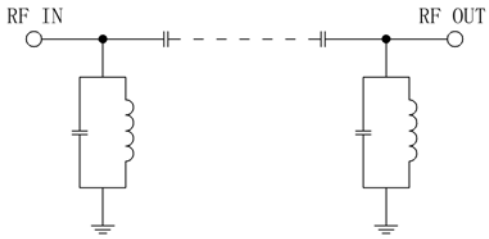
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

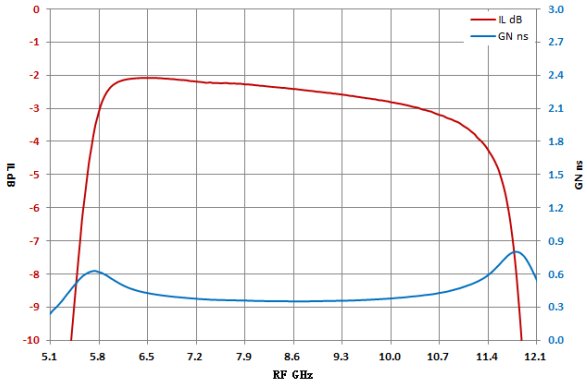
参考实物图

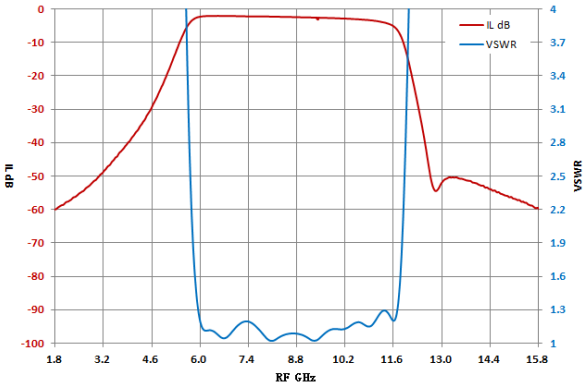


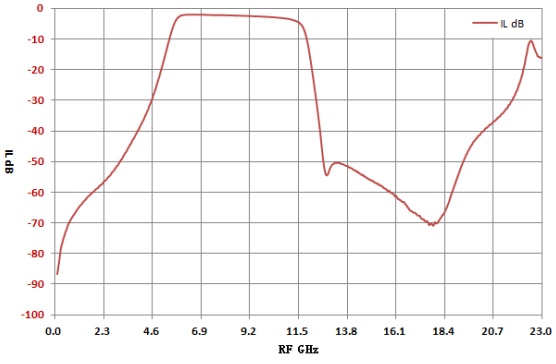
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

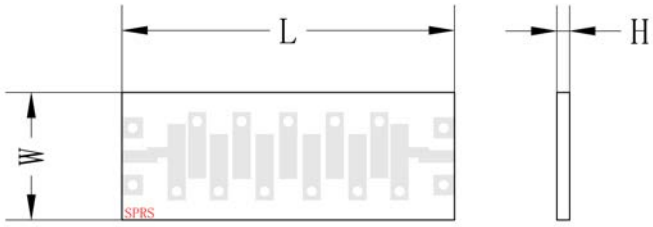
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	8.0	GHz
工作带宽	6.0-10.0	GHz
中心损耗	2.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-4.4GHz	dBc
带外抑制	40@12.0-20.0GHz	dBc

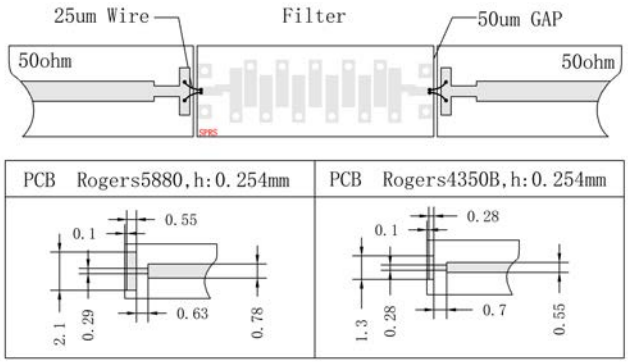
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：5.5，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



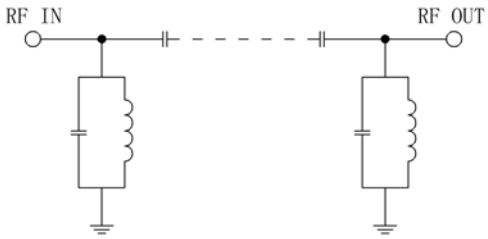
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

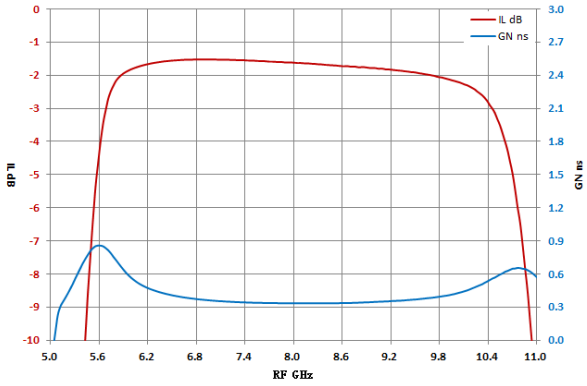
参考实物图

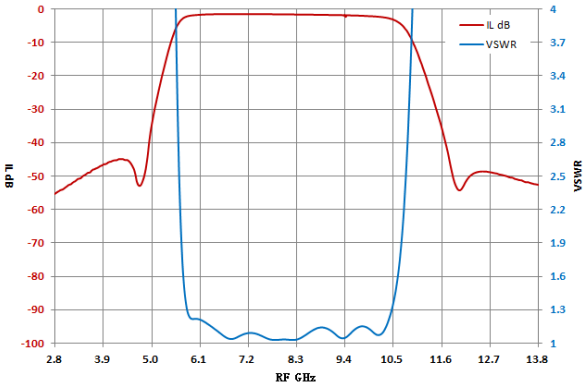


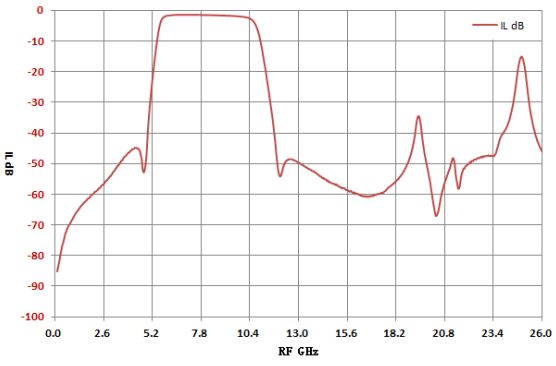
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

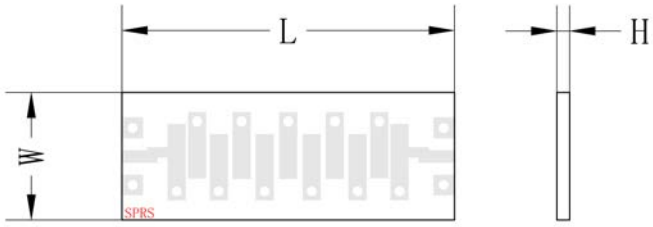
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.0	GHz
工作带宽	6.0-12.0	GHz
中心损耗	1.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-5.3GHz	dBc
带外抑制	40@14.1-21.0GHz	dBc

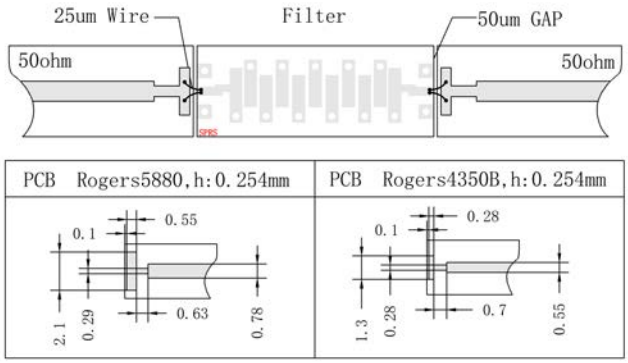
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：4.5，h：0.39

外形图：端口居中



推荐装配图



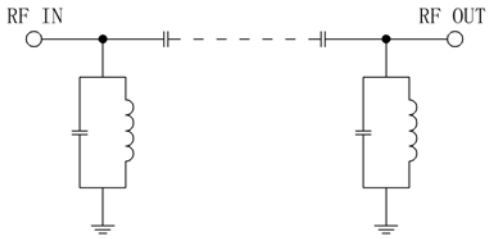
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

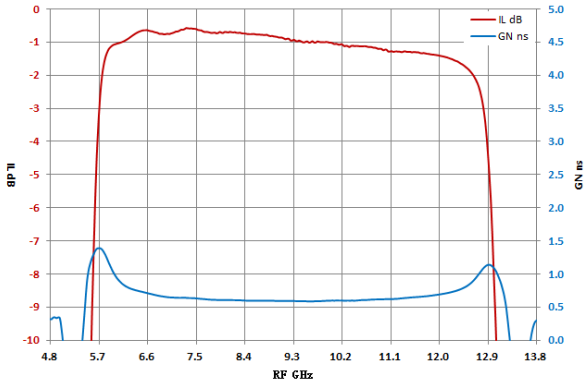
参考实物图

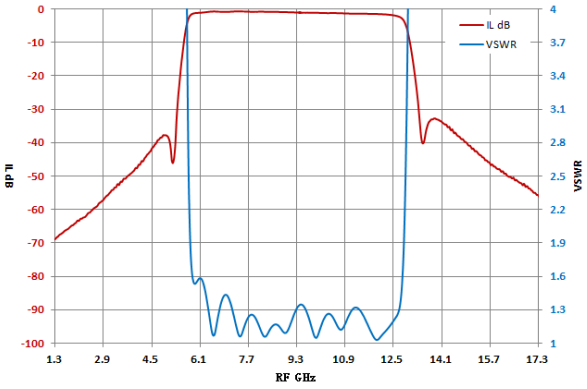


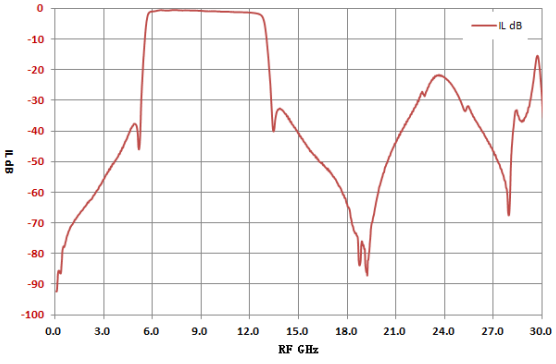
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

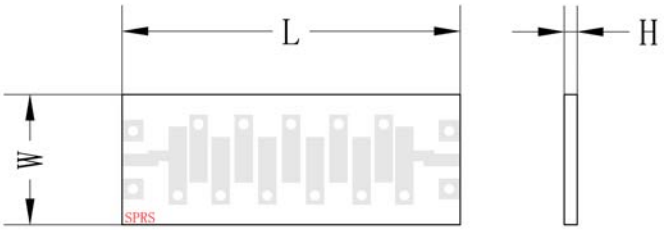
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	12.0	GHz
工作带宽	6.0-18.0	GHz
中心损耗	1.0	dB
带内波动	2.0	dB
驻波比	1.8:1	
群时延波动	0.6	ns
带外抑制	40@DC-4.5GHz	dBc
带外抑制	40@20.0-23.5GHz	dBc

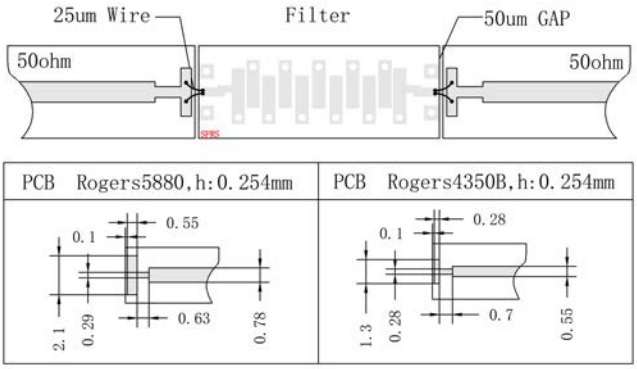
其它要求：设计保证

承受功率	0.5W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：8.0，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

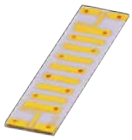
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

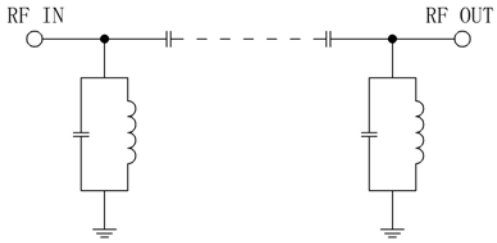
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

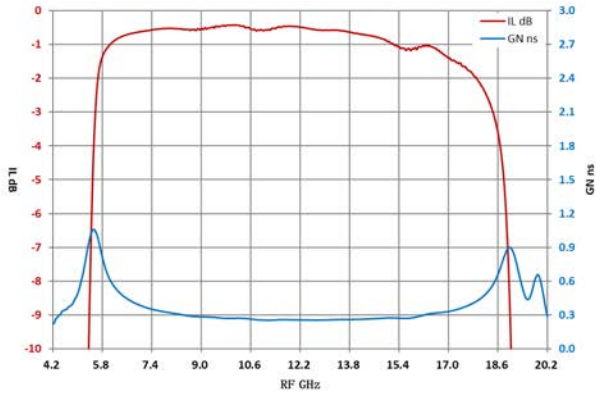
参考图

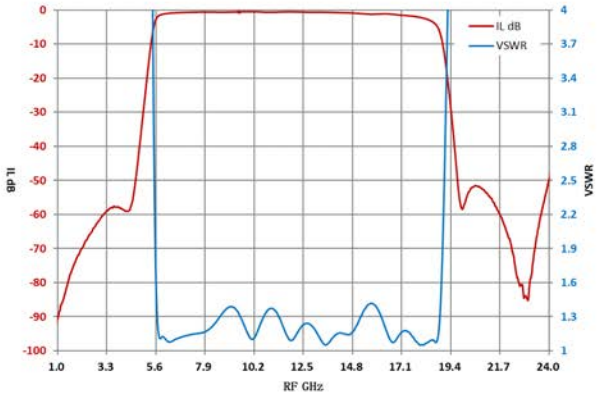


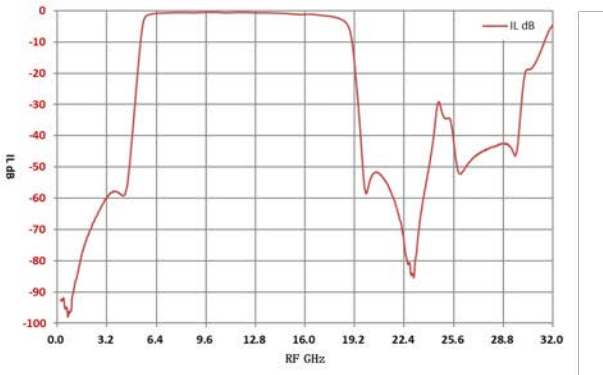
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



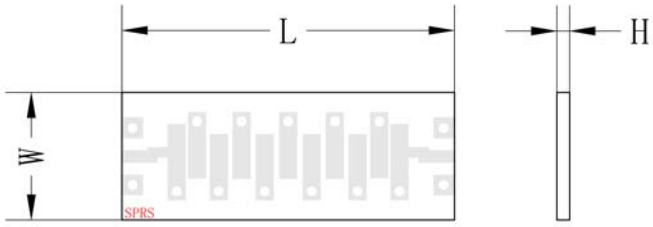
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	6.8	GHz
工作带宽	6.1-7.5	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	35@DC-5.1GHz	dBc
带外抑制	40@8.6-14.0GHz	dBc

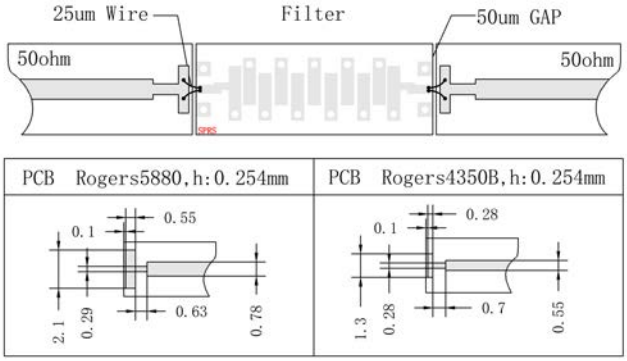
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：5.0，h：0.26

外形图：端口居中



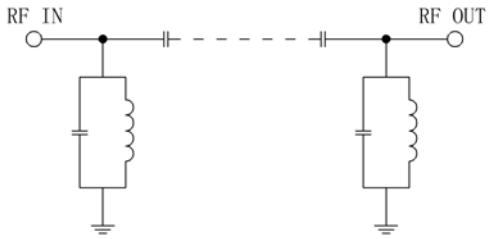
推荐装配图



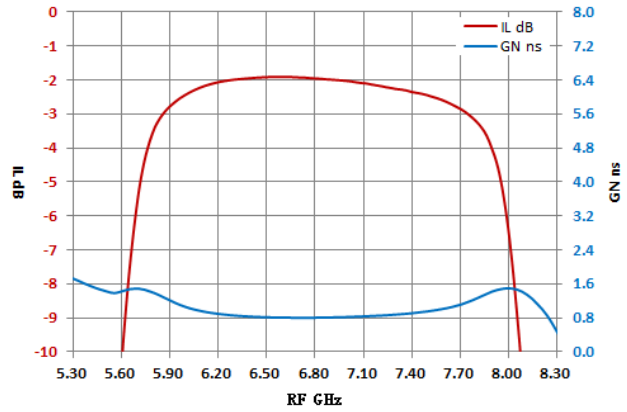
注意事项

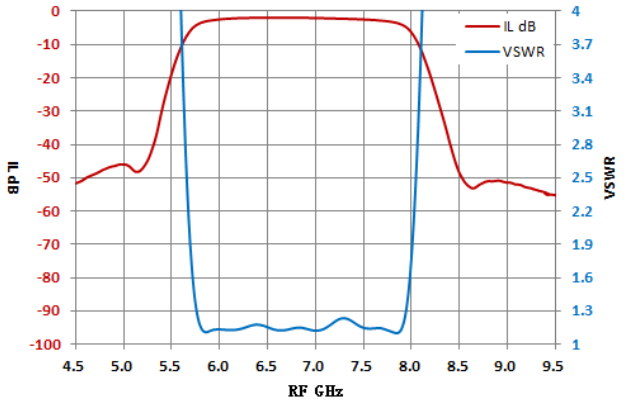
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

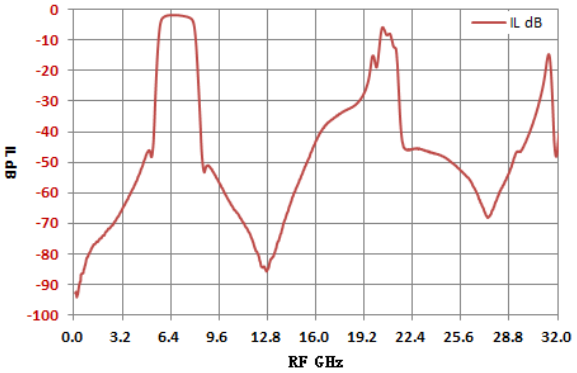
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

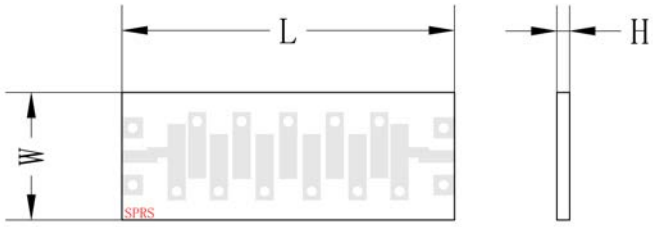
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	7.5	GHz
工作带宽	6.1-8.9	GHz
中心损耗	2.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-4.9GHz	dBc
带外抑制	40@10.3-17.0GHz	dBc

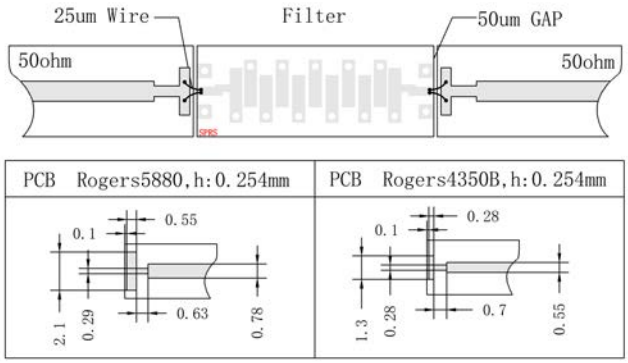
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：4.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



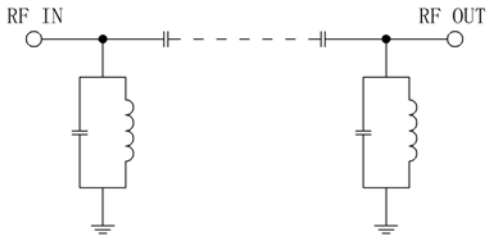
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

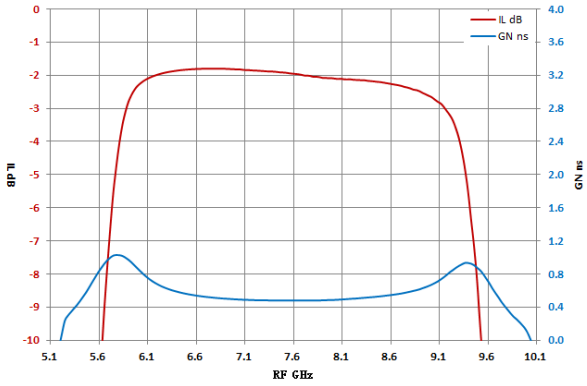
参考实物图

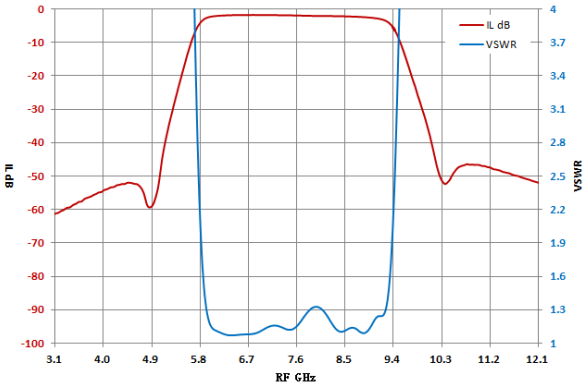


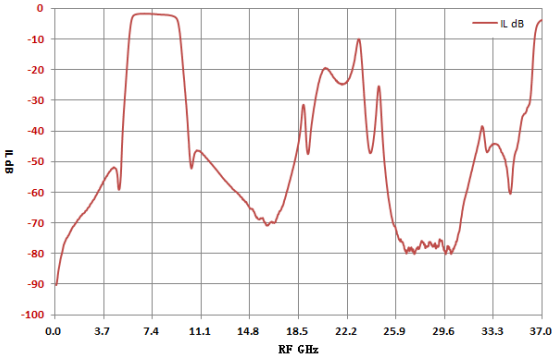
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



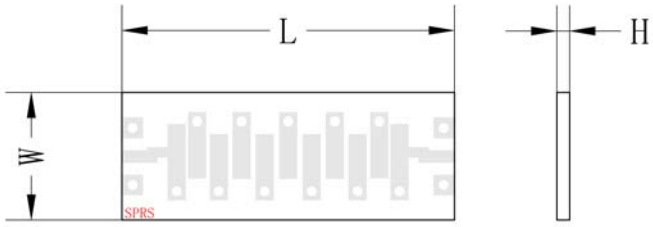
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	7.6	GHz
工作带宽	6.1-9.0	GHz
中心损耗	1.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-4.7GHz	dBc
带外抑制	40@11.0-17.0GHz	dBc

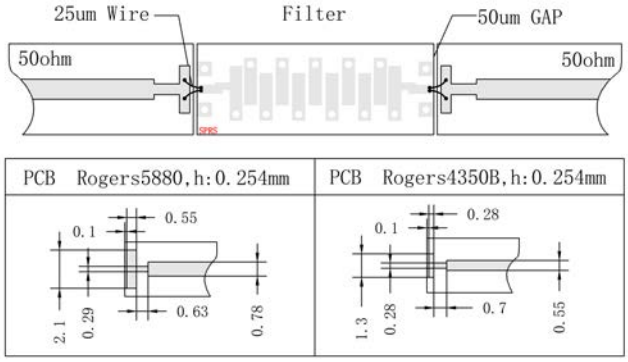
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：4.5，h：0.26

外形图：端口居中



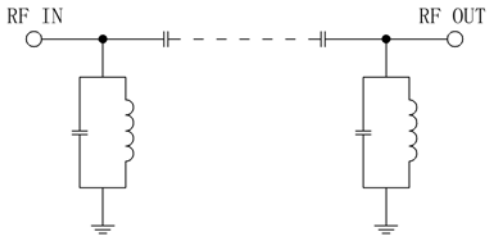
推荐装配图



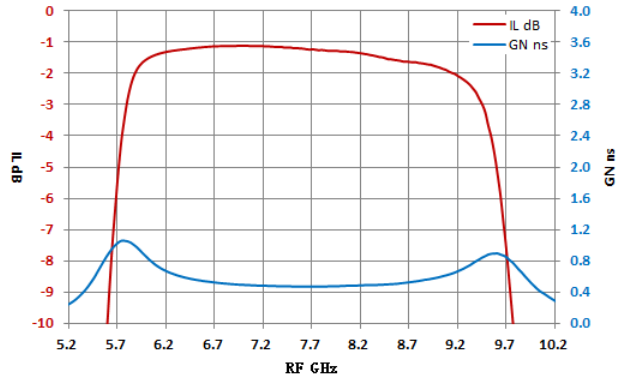
注意事项

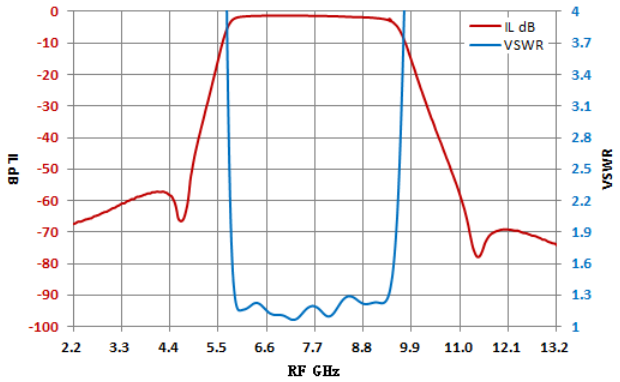
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

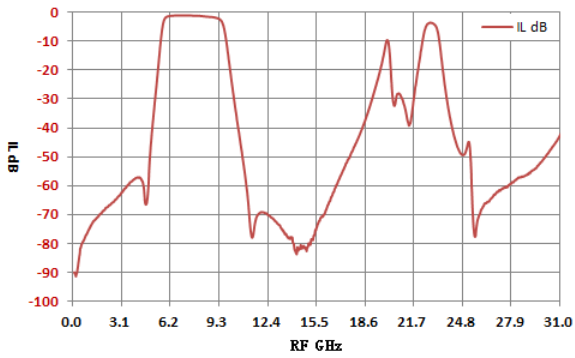
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

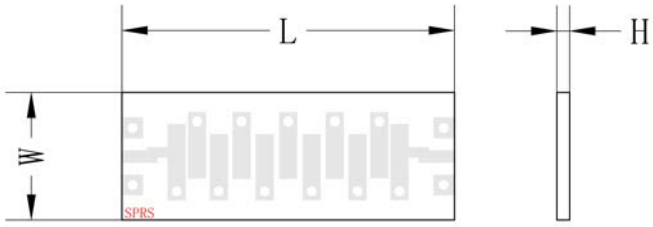
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	6.9	GHz
工作带宽	6.2-7.6	GHz
中心损耗	2.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-5.0GHz	dBc
带外抑制	40@9.1-16.0GHz	dBc

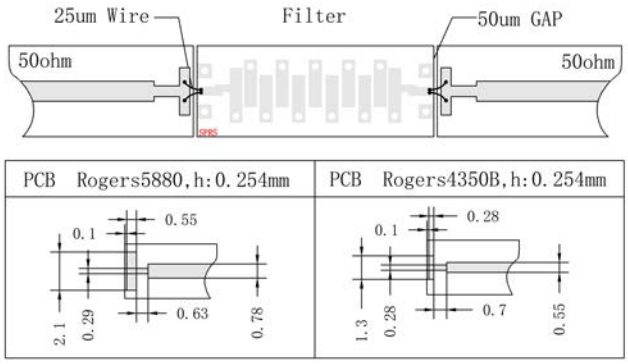
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：5.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



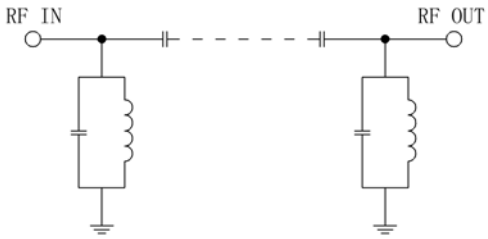
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

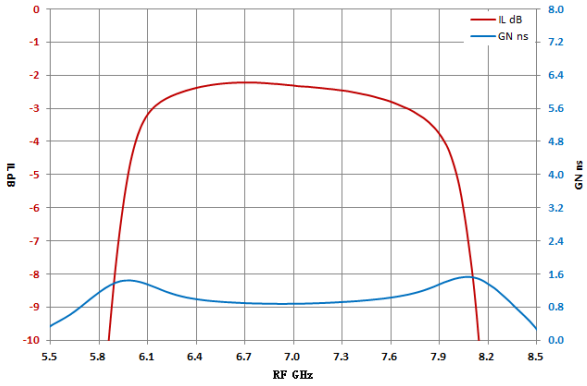
参考实物图

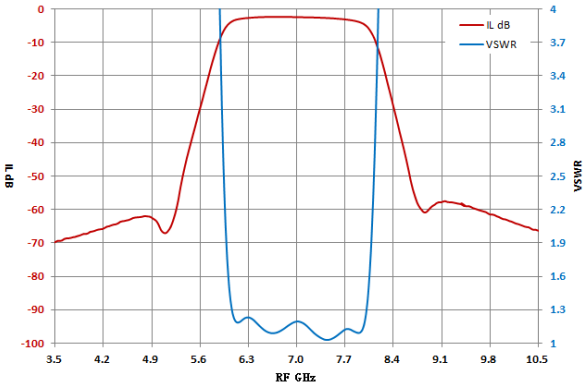


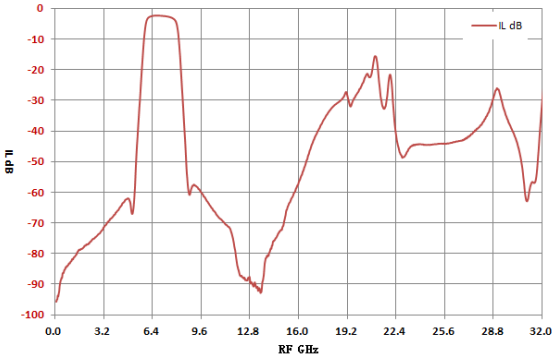
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



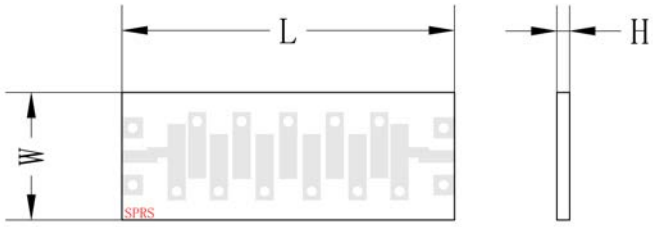
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	7.4	GHz
工作带宽	6.2-8.6	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.6	ns
带外抑制	40@DC-4.8GHz	dBc
带外抑制	40@10.4-16.0GHz	dBc

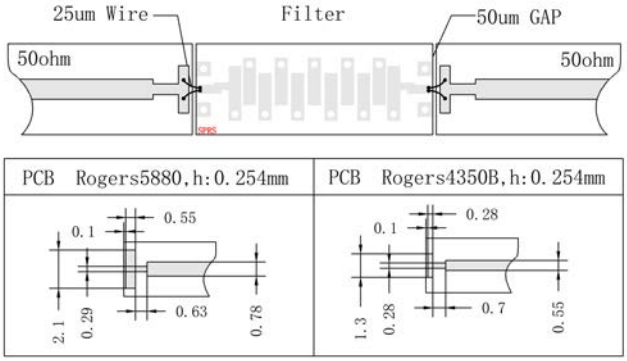
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：4.5，h：0.26

外形图：端口居中



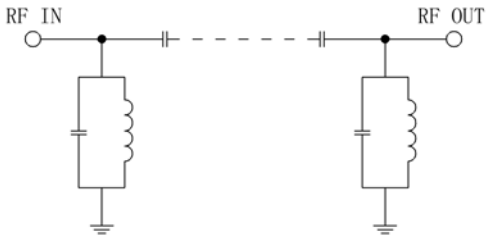
推荐装配图



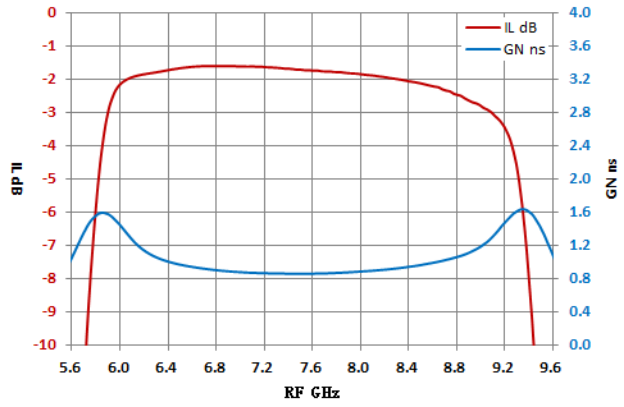
注意事项

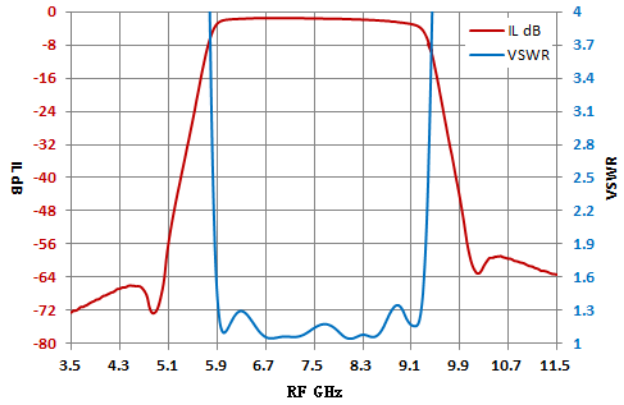
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

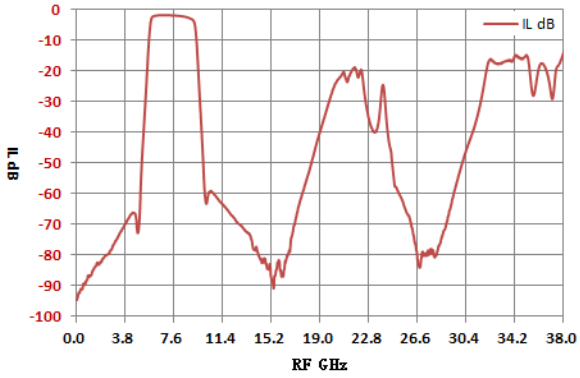
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



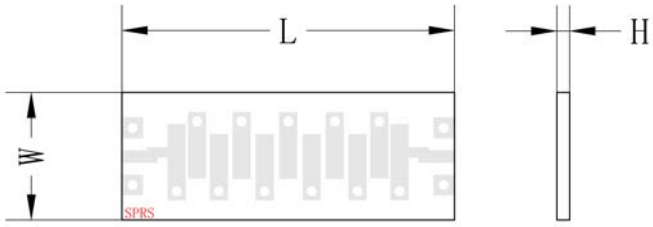
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	6.5	GHz
工作带宽	6.4-6.6	GHz
中心损耗	5.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	35@DC-5.7GHz	dBc
带外抑制	35@7.2-14.0GHz	dBc

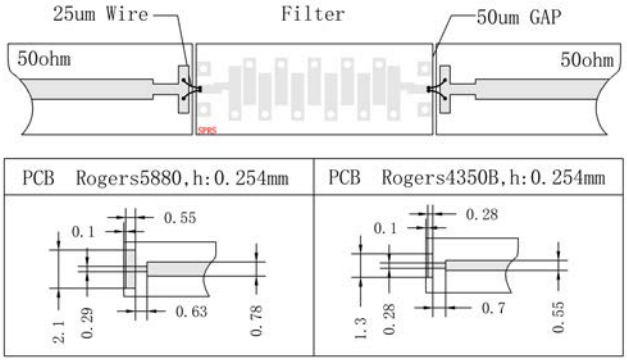
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：5.5，h：0.26

外形图：端口居中



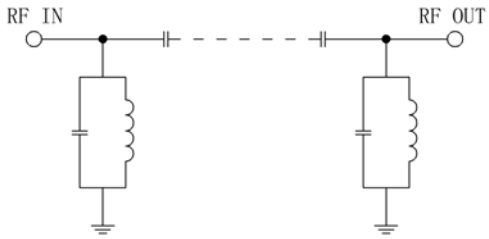
推荐装配图



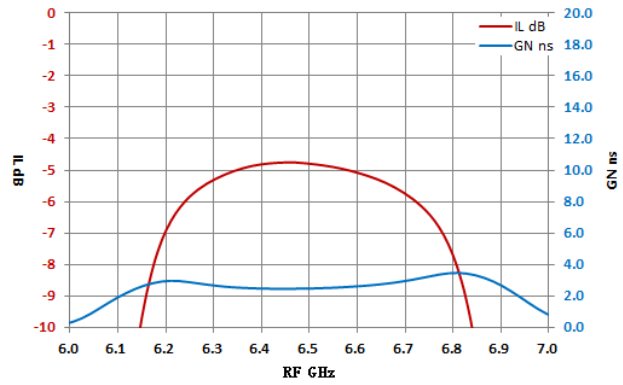
注意事项

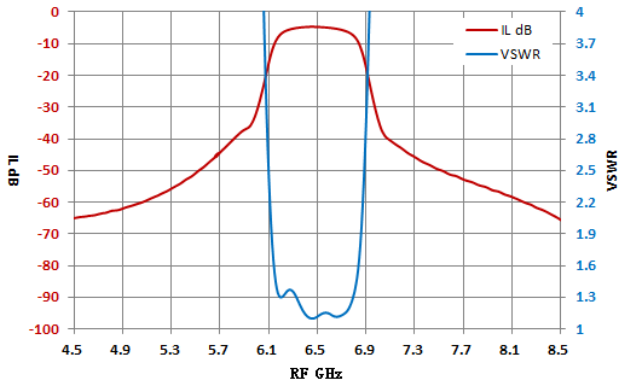
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

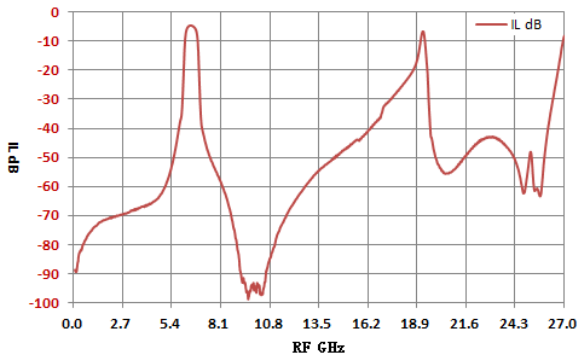
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

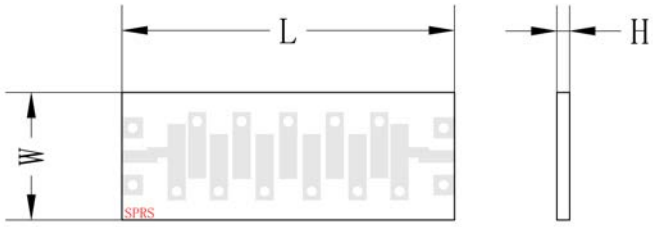
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	7.05	GHz
工作带宽	6.4-7.7	GHz
中心损耗	2.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-5.3GHz	dBc
带外抑制	40@8.9-16.0GHz	dBc

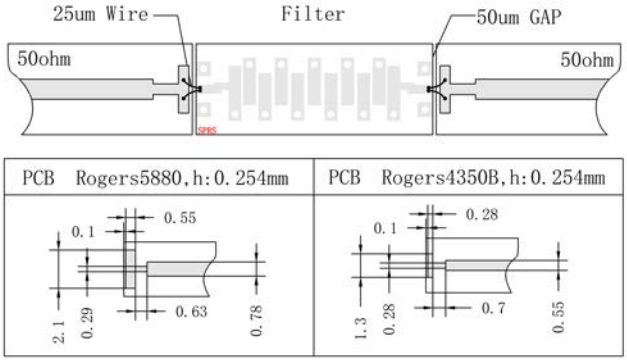
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：5.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



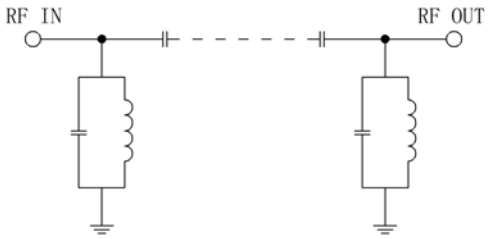
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

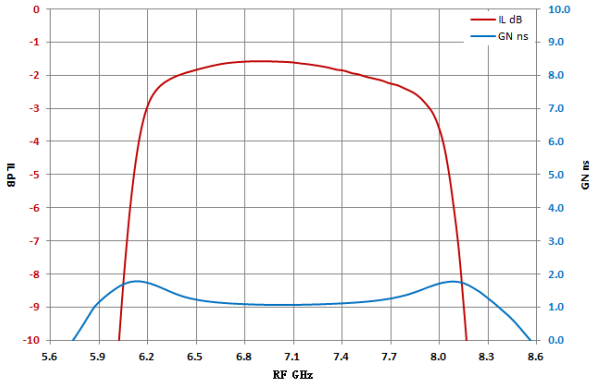
参考实物图

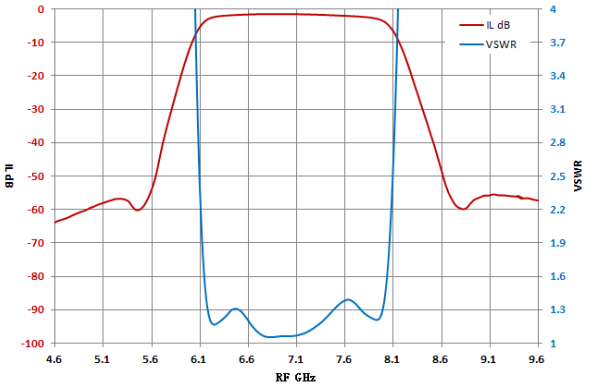


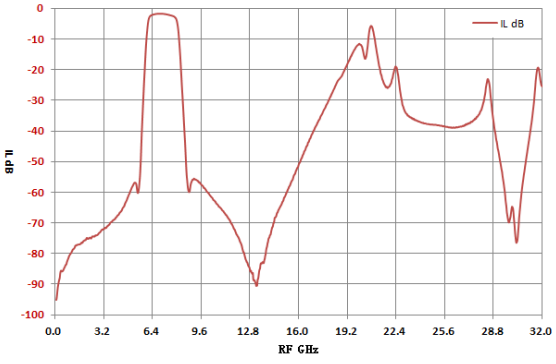
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

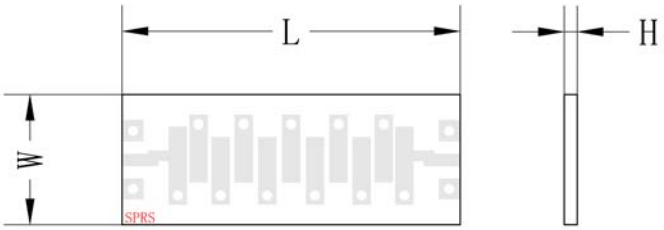
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	7.25	GHz
工作带宽	6.4-8.1	GHz
中心损耗	2.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	1.0	ns
带外抑制	50@DC-5.4GHz	dBc
带外抑制	40@9.0-17.0GHz	dBc

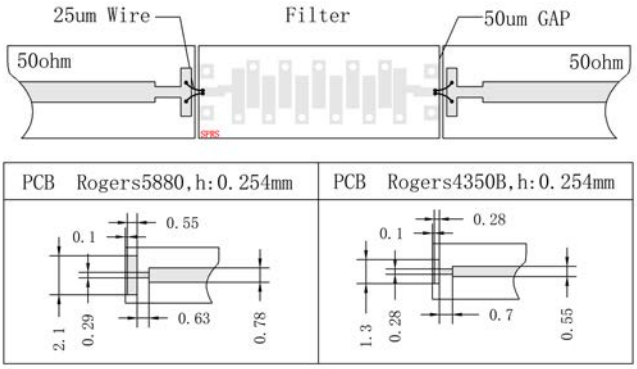
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：7.0，W：5.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.74mm,端口可互换;

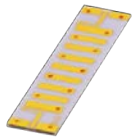
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

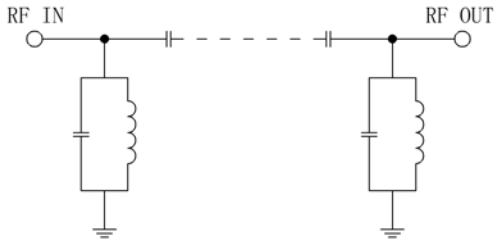
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

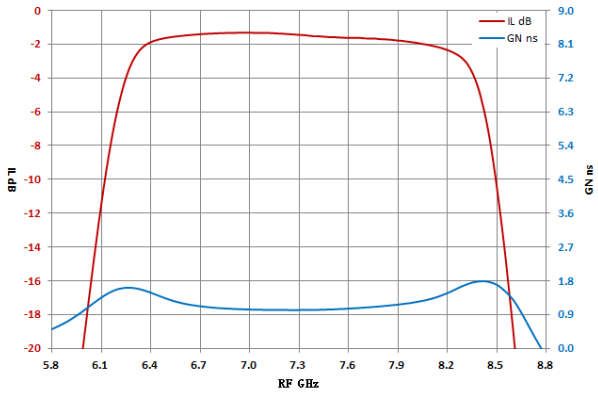
参考图

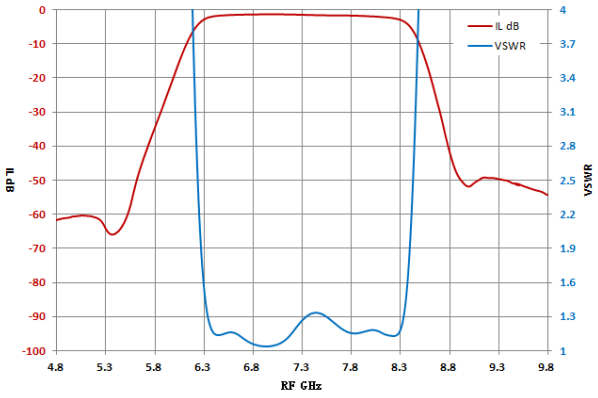


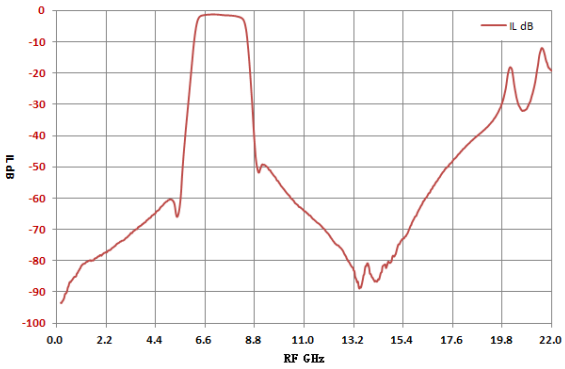
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



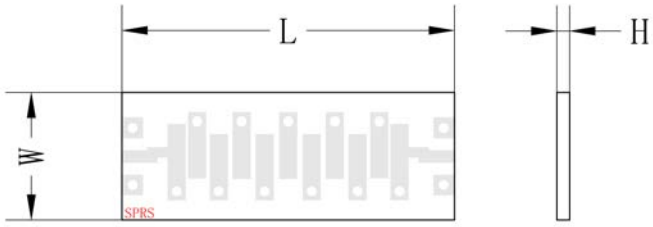
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	8.2	GHz
工作带宽	6.4-10.0	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-5.1GHz	dBc
带外抑制	40@11.9-19.0GHz	dBc

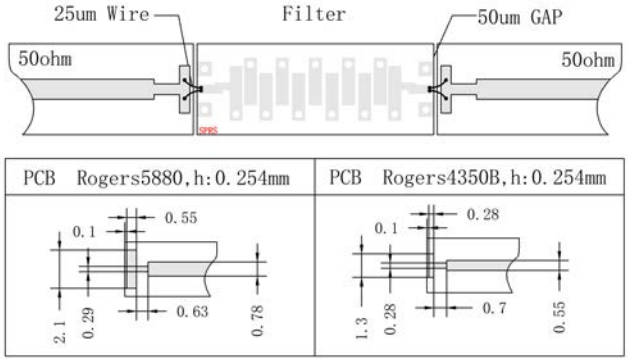
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：5.5，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



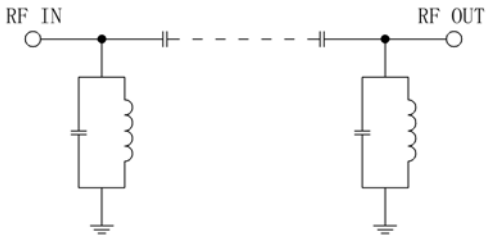
推荐装配图



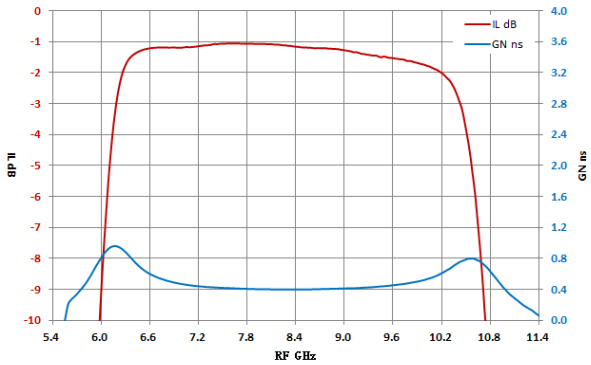
注意事项

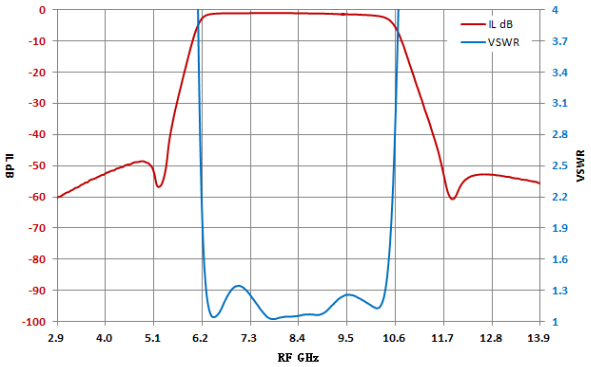
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

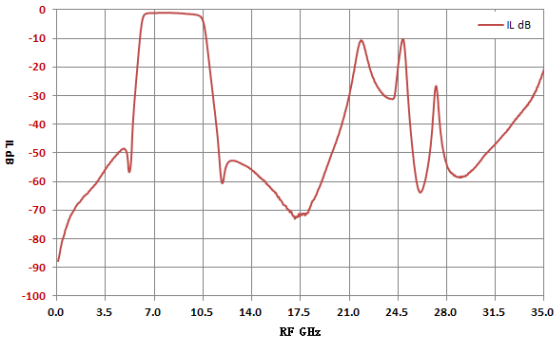
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

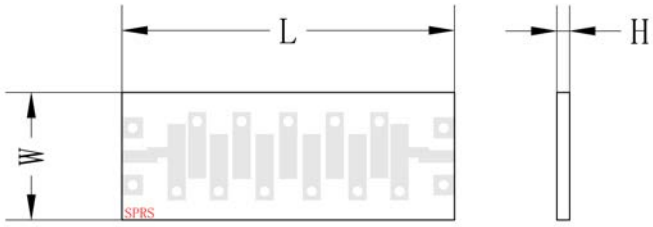
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	6.65	GHz
工作带宽	6.5-6.8	GHz
中心损耗	7.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	1.0	ns
带外抑制	40@DC-5.9GHz	dBc
带外抑制	40@7.4-16.0GHz	dBc

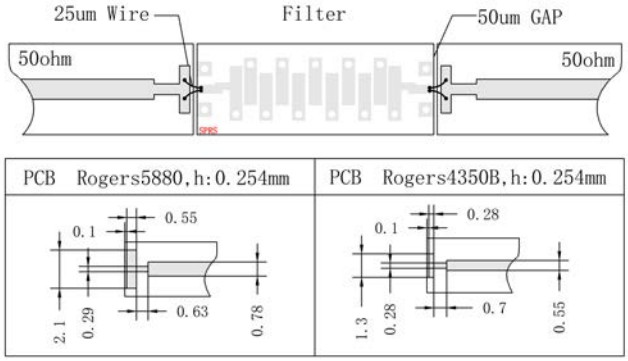
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：5.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



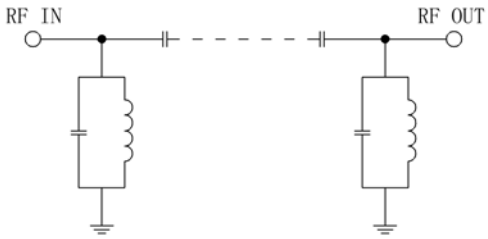
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

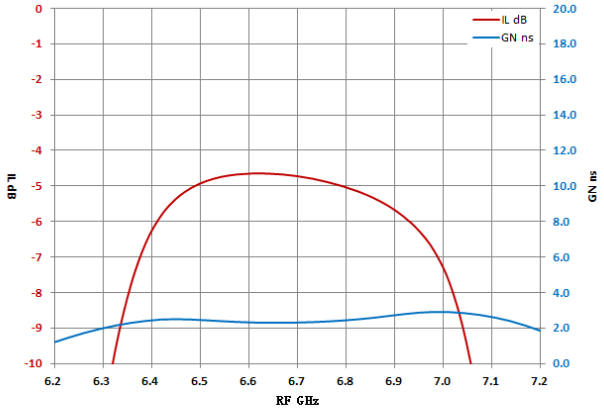
参考实物图

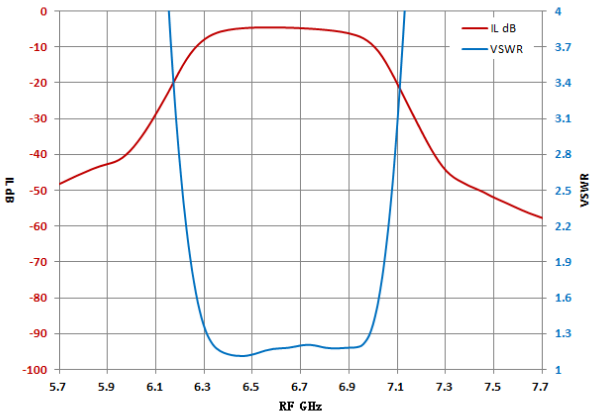


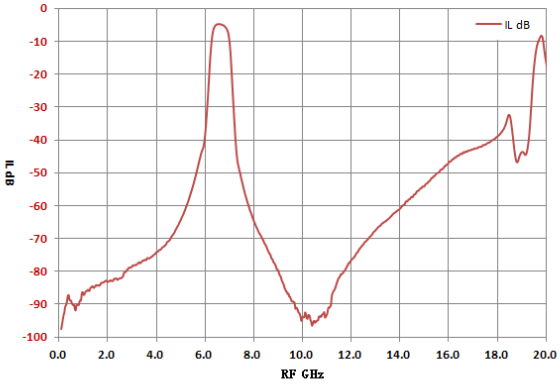
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

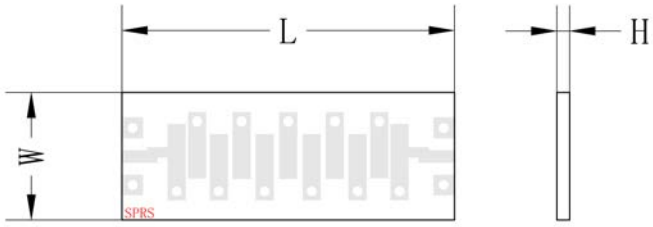
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	7.15	GHz
工作带宽	6.5-7.8	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-5.2GHz	dBc
带外抑制	38@9.2-15.0GHz	dBc

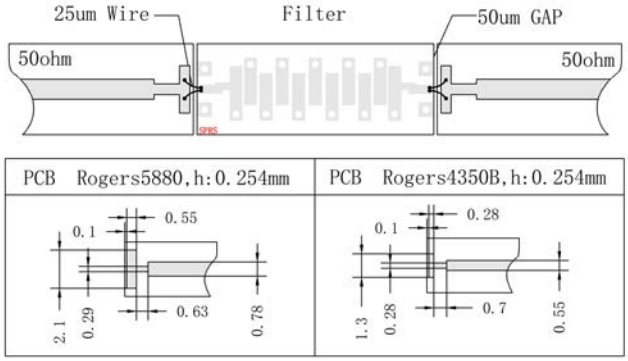
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：5.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



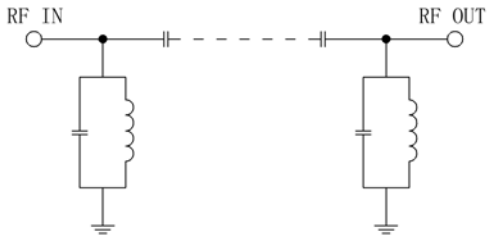
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

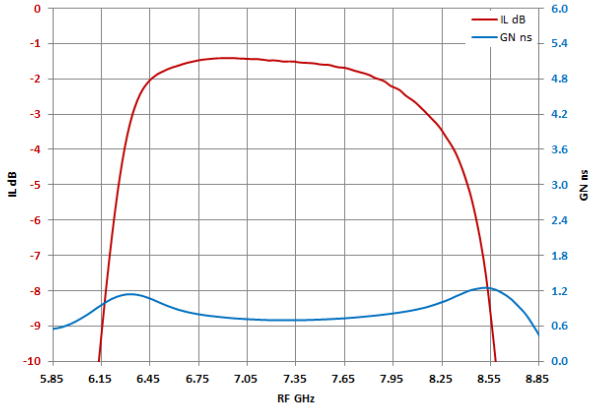
参考实物图

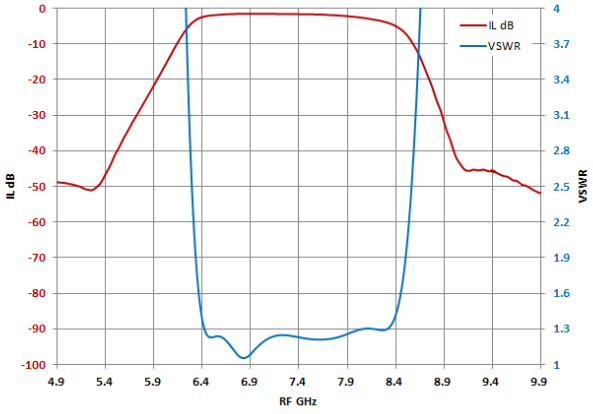


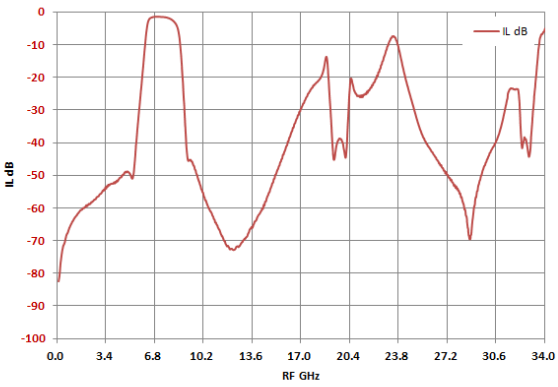
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

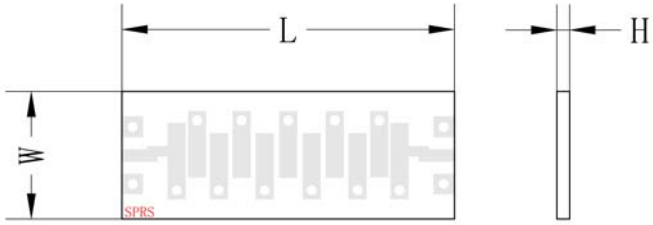
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	12.5	GHz
工作带宽	6.5-18.5	GHz
中心损耗	1.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-4.4GHz	dBc

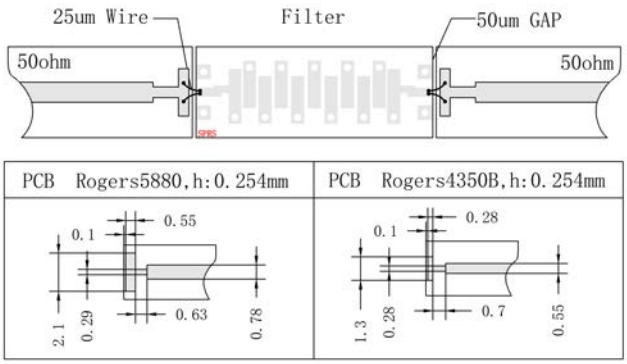
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.5，W：5.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



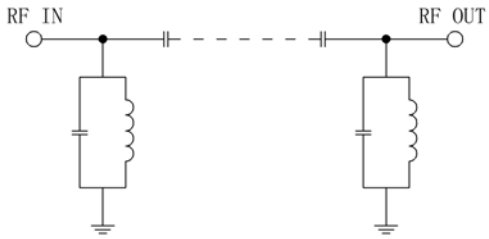
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.74mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

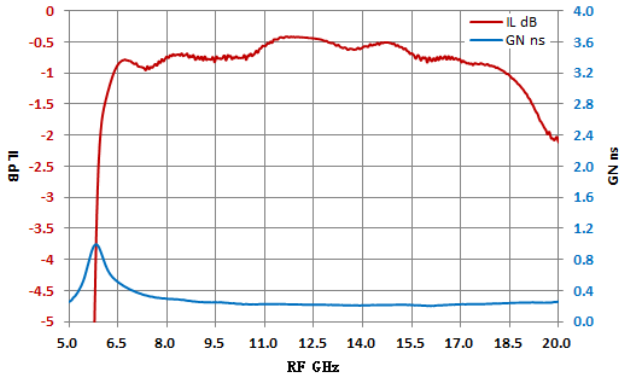
参考实物图

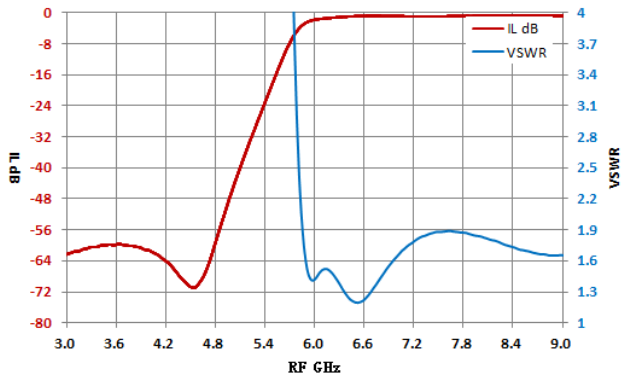


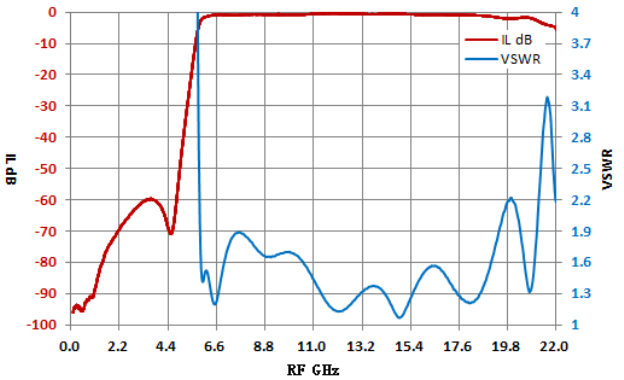
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

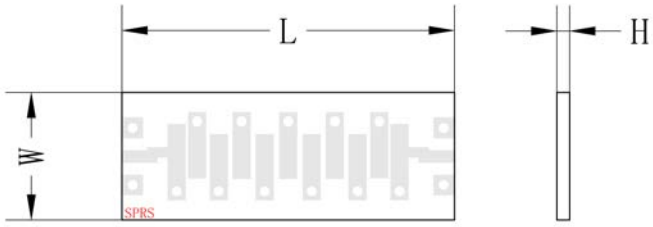
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.1	GHz
工作带宽	6.6-11.6	GHz
中心损耗	1.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-4.6GHz	dBc
带外抑制	40@13.8-24.0GHz	dBc

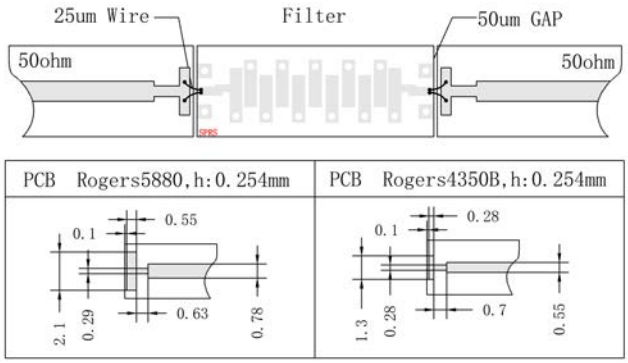
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



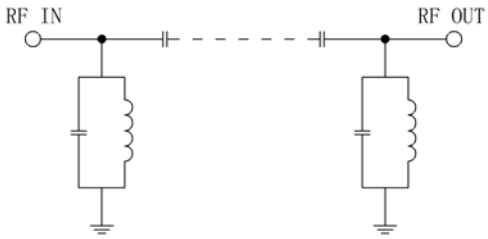
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

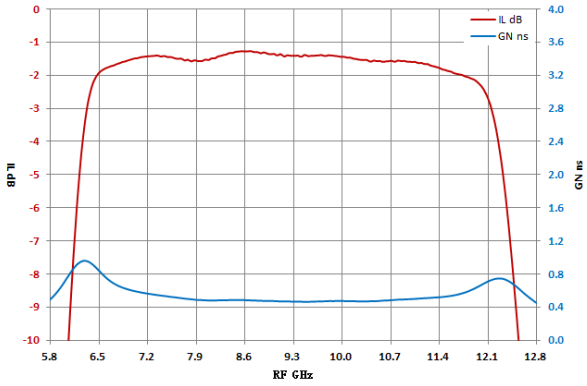
参考实物图

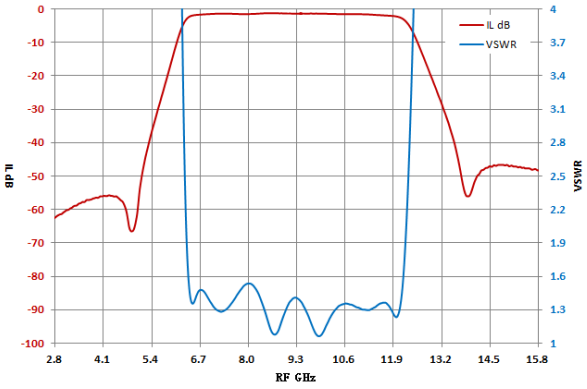


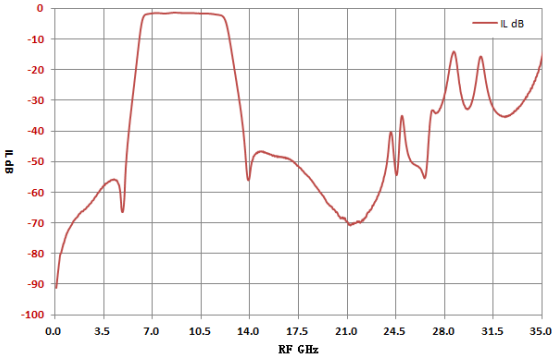
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



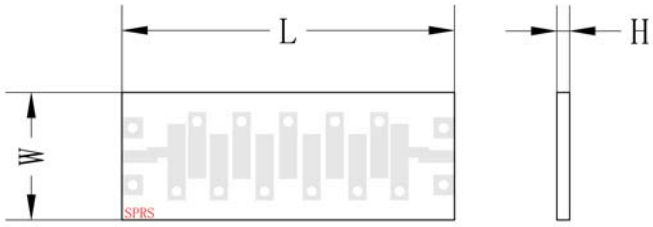
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	7.4	GHz
工作带宽	6.7-8.1	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-5.4GHz	dBc
带外抑制	40@9.8-16.0GHz	dBc

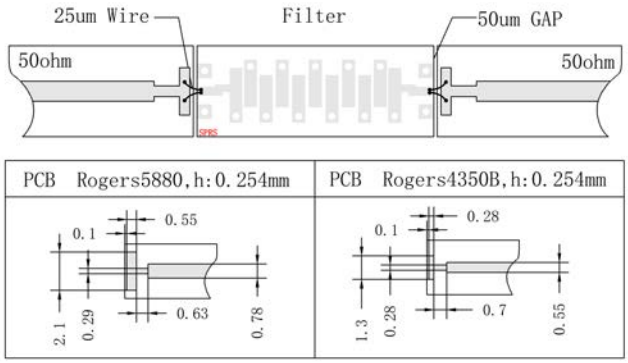
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：4.5，h：0.26

外形图：端口居中



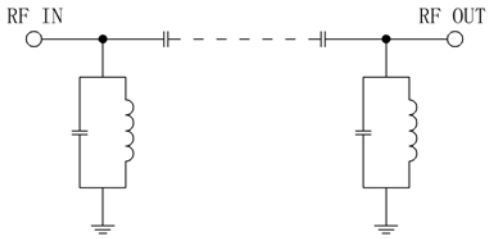
推荐装配图



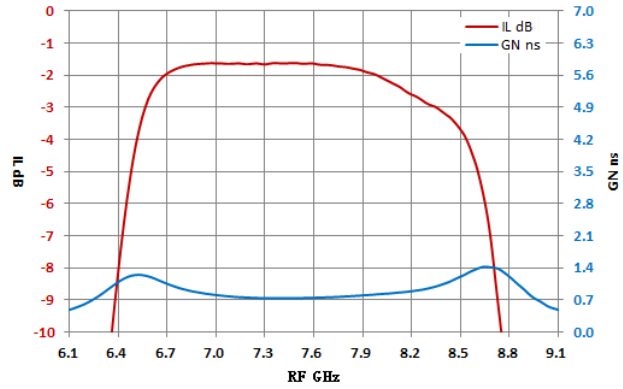
注意事项

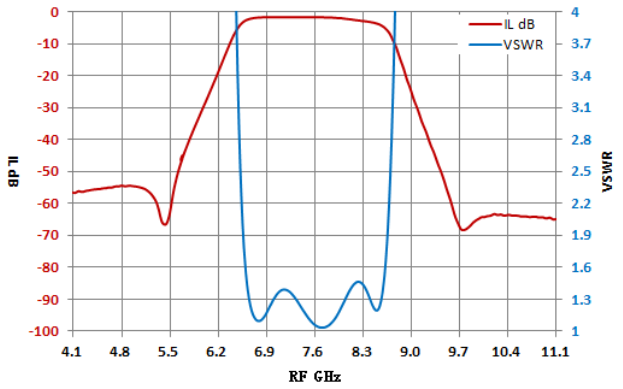
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

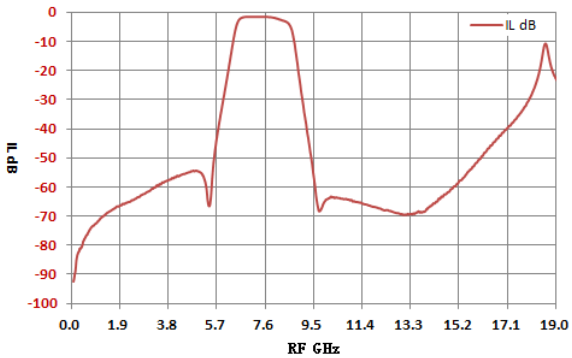
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



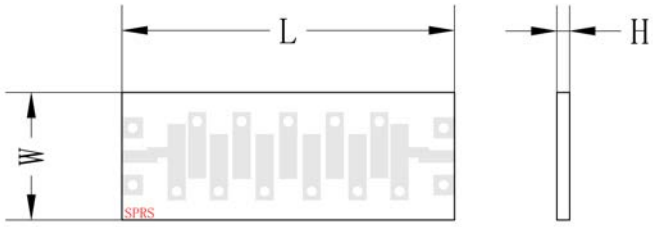
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	7.8	GHz
工作带宽	6.7-8.9	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-5.1GHz	dBc
带外抑制	40@10.6-17.0GHz	dBc

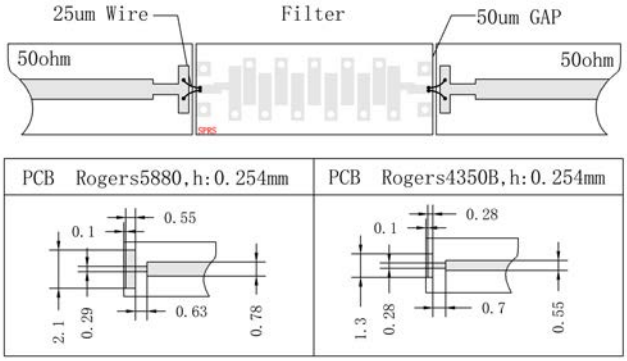
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：4.5，h：0.26

外形图：端口居中



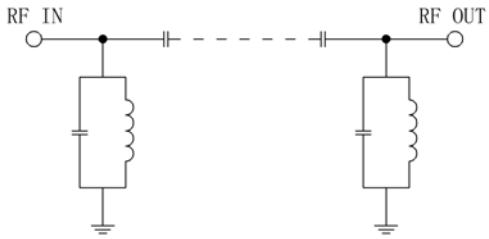
推荐装配图



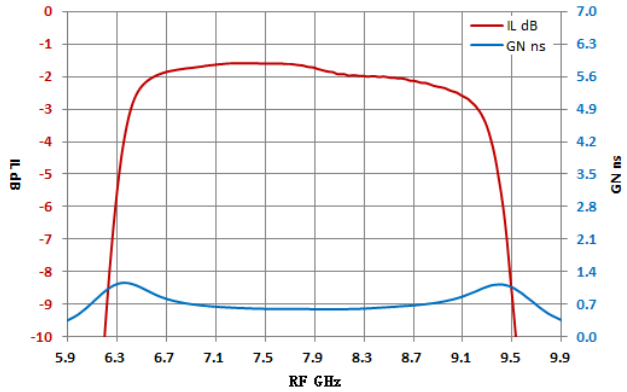
注意事项

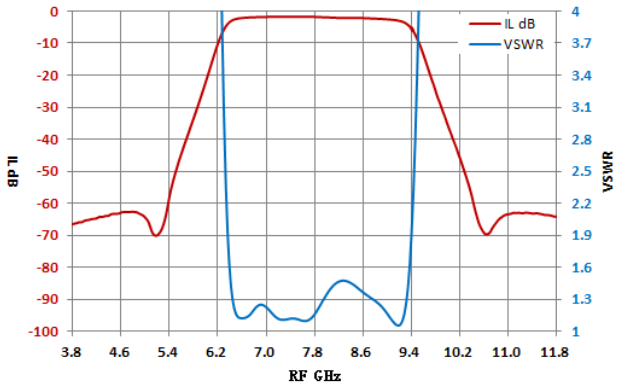
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

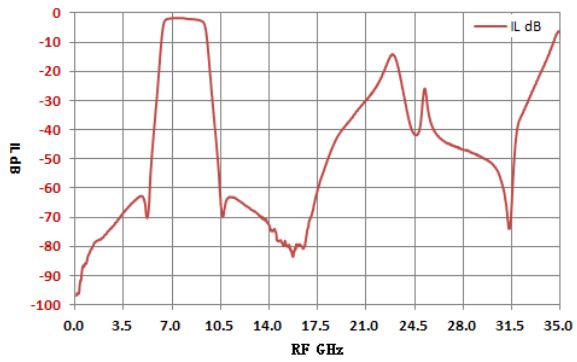
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



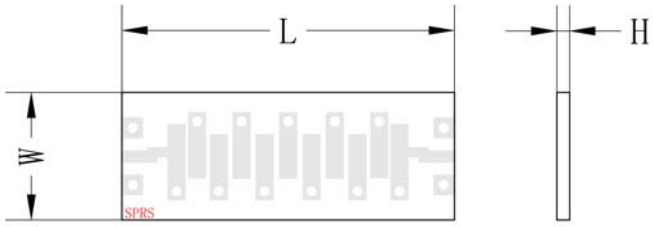
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	7.8	GHz
工作带宽	6.7-8.9	GHz
中心损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-5.6GHz	dBc
带外抑制	35@10.3-18.0GHz	dBc

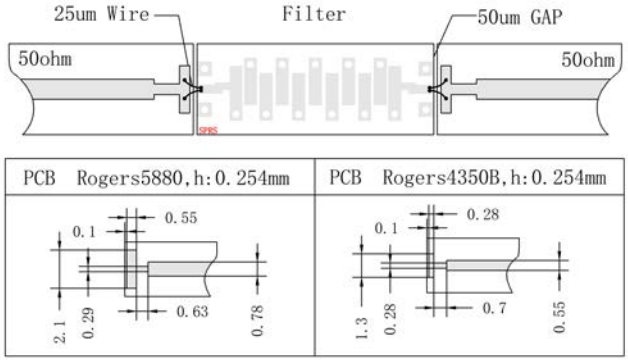
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：4.5，h：0.26

外形图：端口居中



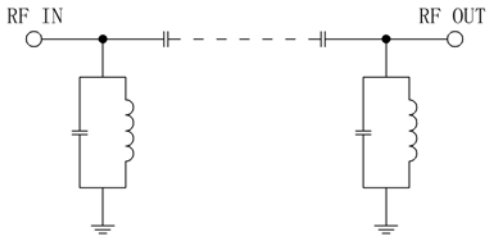
推荐装配图



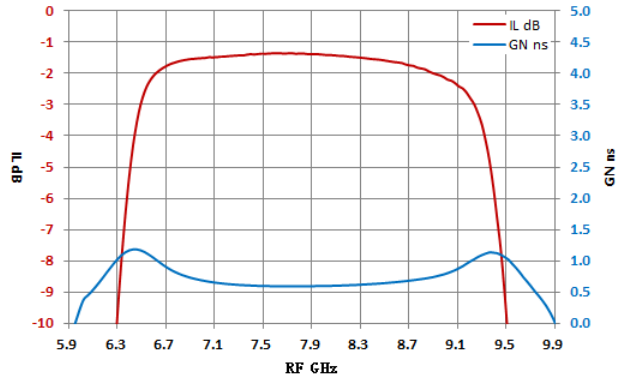
注意事项

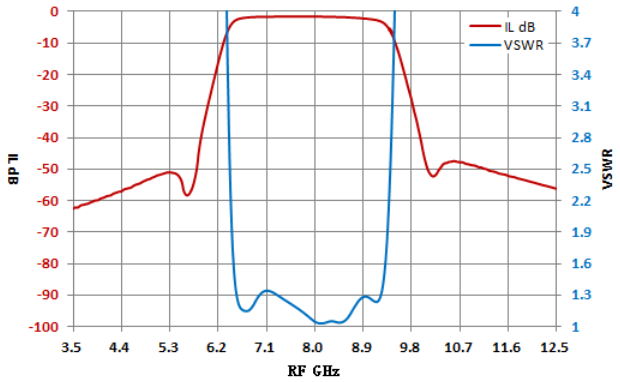
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

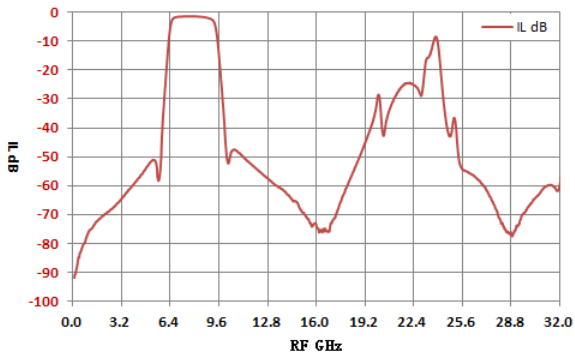
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



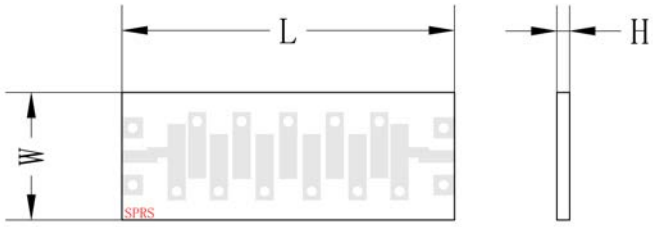
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	7.0	GHz
工作带宽	6.8-7.1	GHz
中心损耗	3.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-5.5GHz	dBc
带外抑制	40@8.0-15.0GHz	dBc

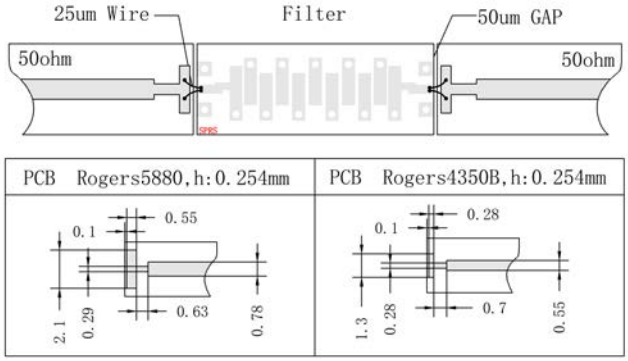
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：5.0，h：0.26

外形图：端口居中



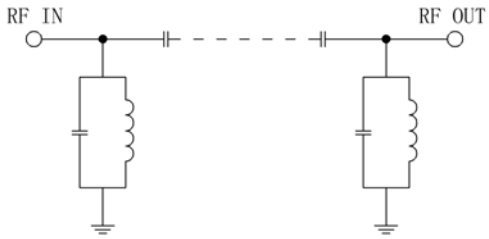
推荐装配图



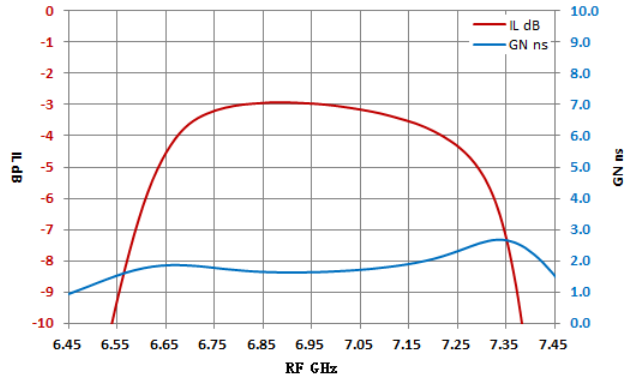
注意事项

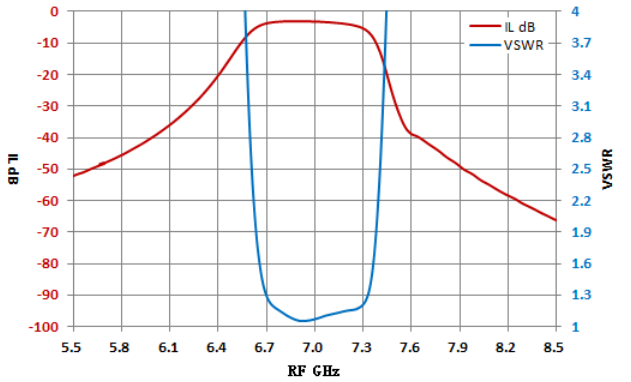
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

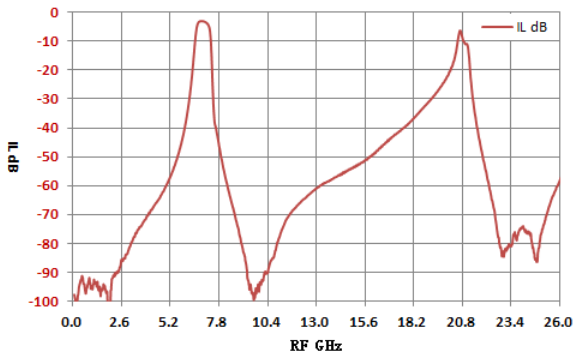
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



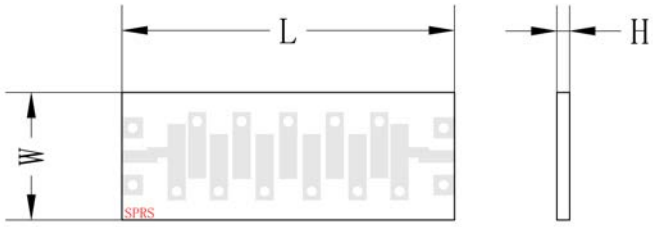
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	7.3	GHz
工作带宽	6.9-7.7	GHz
中心损耗	2.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-5.0GHz	dBc
带外抑制	40@8.6-15.0GHz	dBc

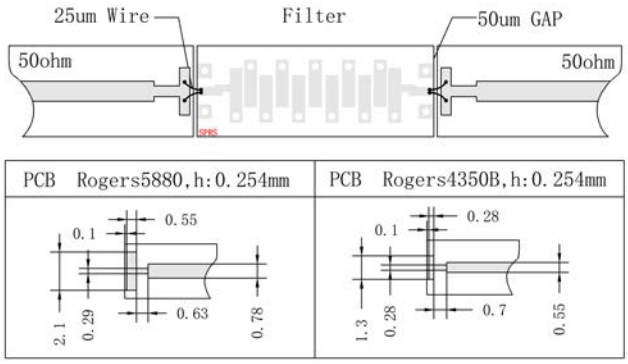
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：4.5，h：0.26

外形图：端口居中



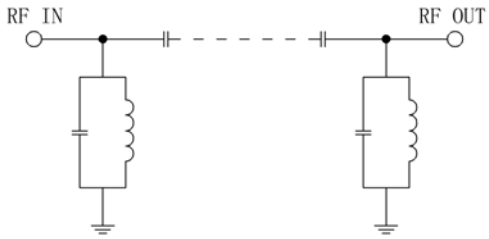
推荐装配图



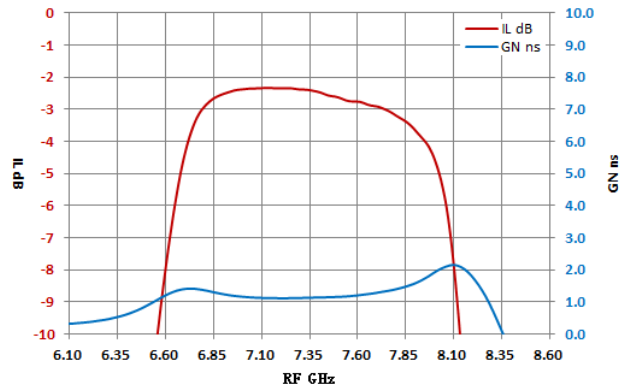
注意事项

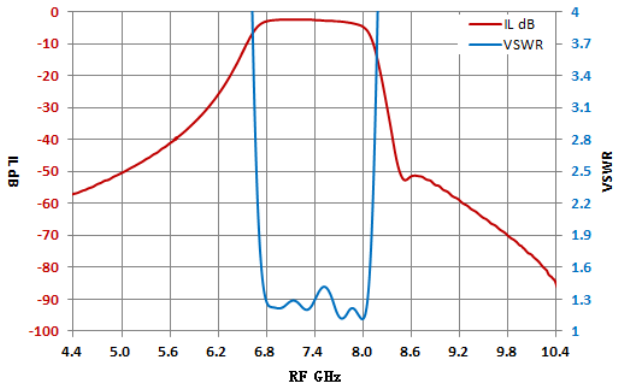
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

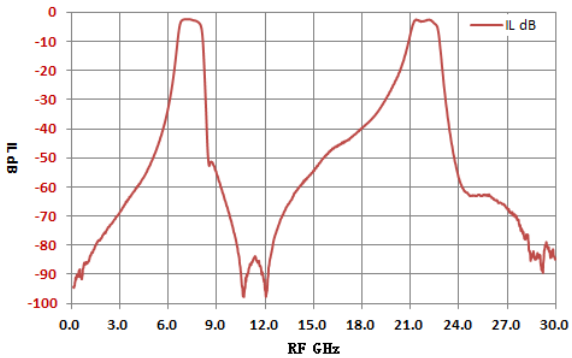
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

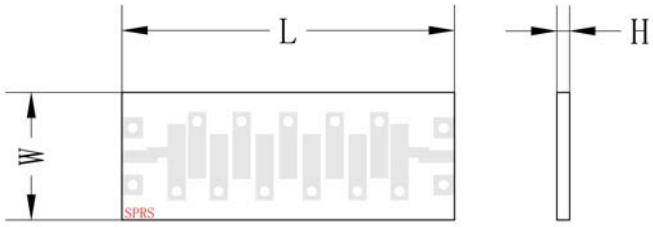
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	8.1	GHz
工作带宽	6.9-9.3	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-5.6GHz	dBc
带外抑制	40@11.0-19.0GHz	dBc

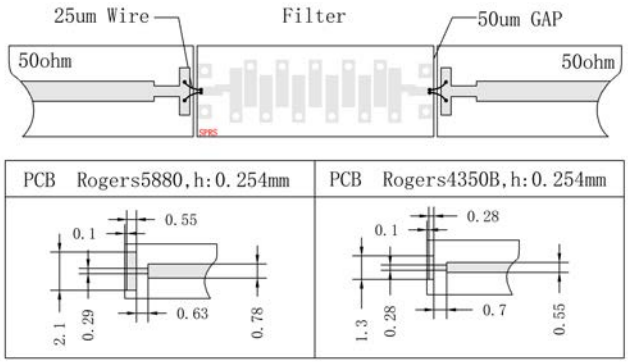
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：4.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



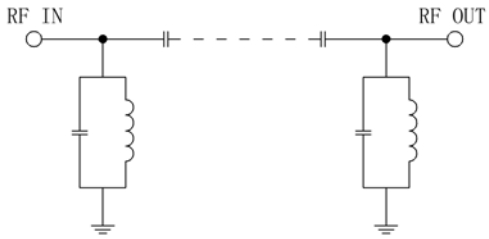
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

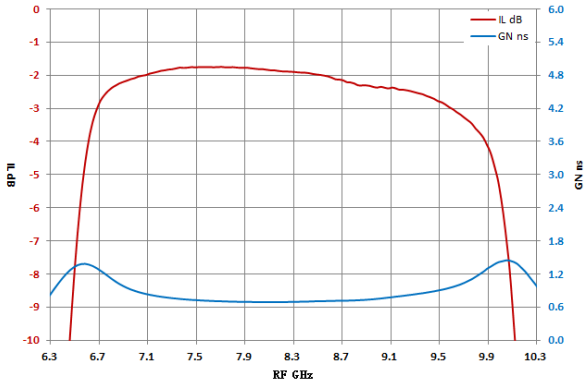
参考实物图

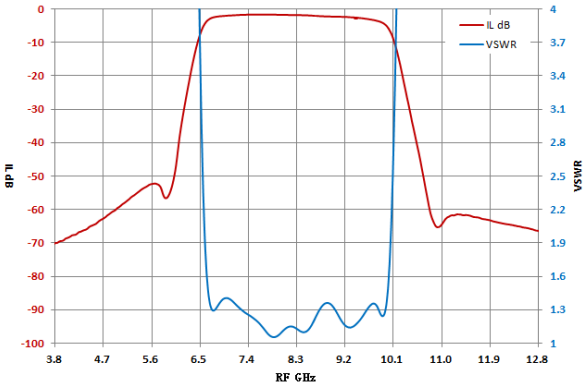


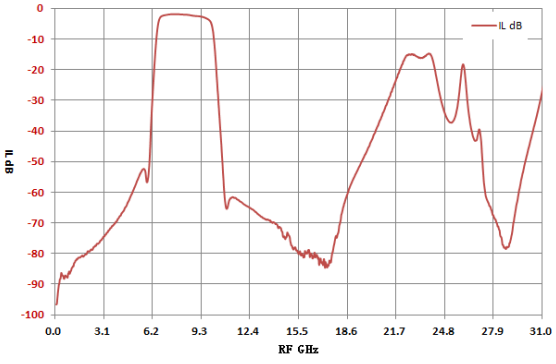
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



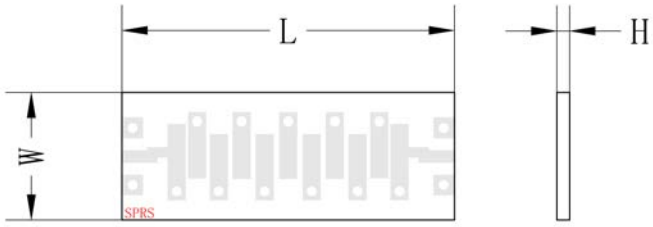
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	7.0	GHz
工作带宽	6.95-7.05	GHz
中心损耗	4.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-6.0GHz	dBc
带外抑制	40@8.0-18.0GHz	dBc

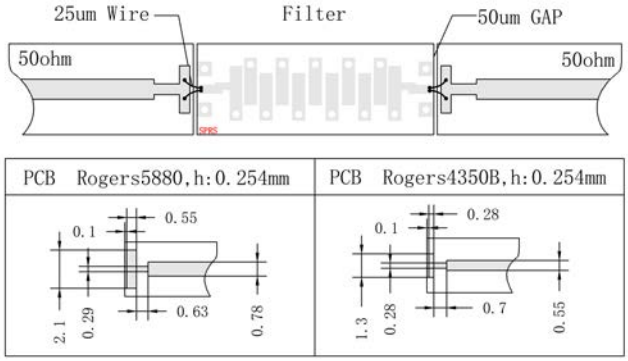
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



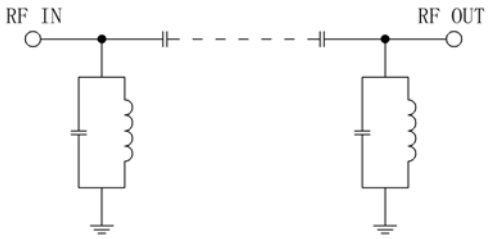
推荐装配图



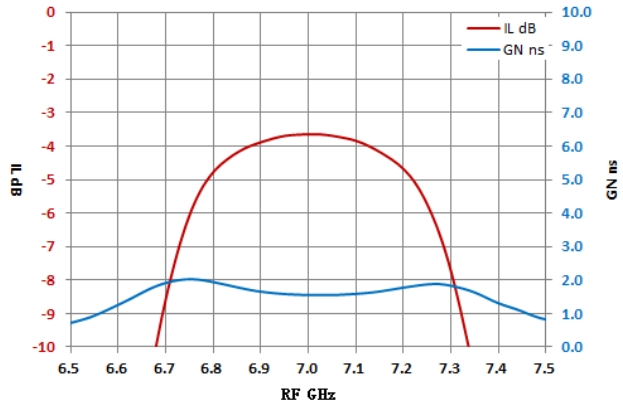
注意事项

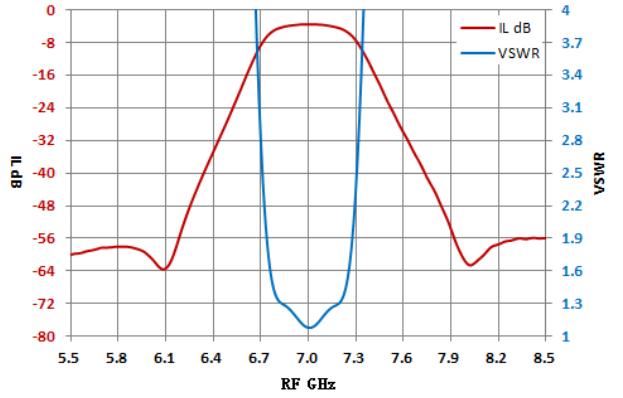
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

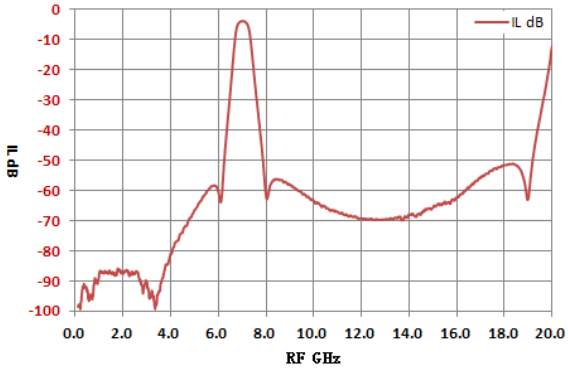
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



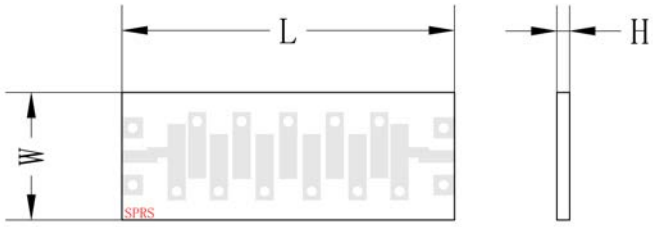
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	8.0	GHz
工作带宽	7.0-9.0	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-5.9GHz	dBc
带外抑制	40@10.6-18.5GHz	dBc

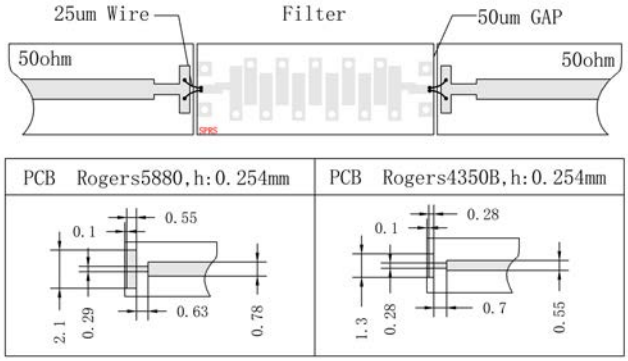
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：4.5，h：0.26

外形图：端口居中



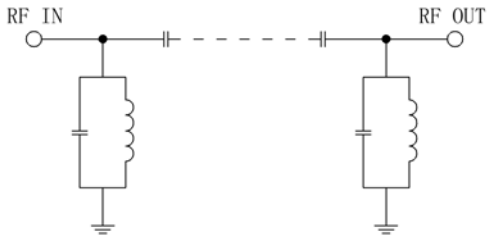
推荐装配图



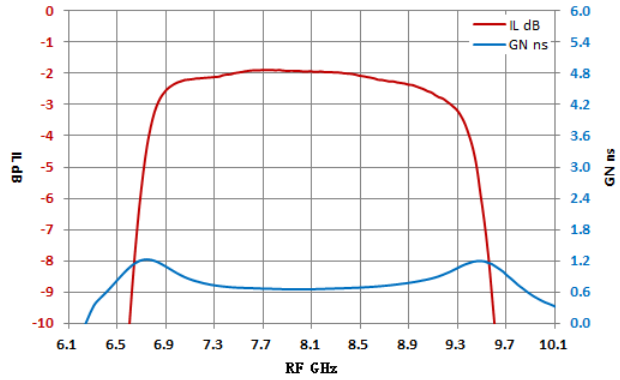
注意事项

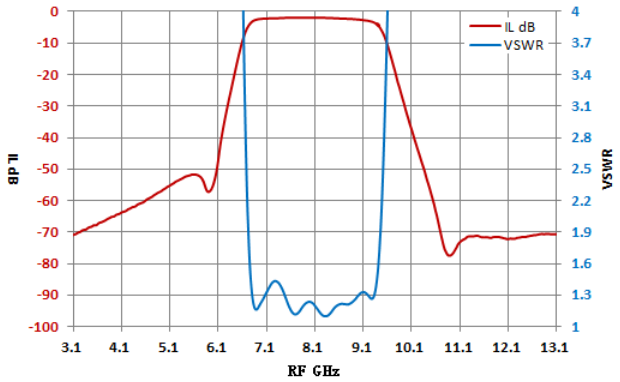
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

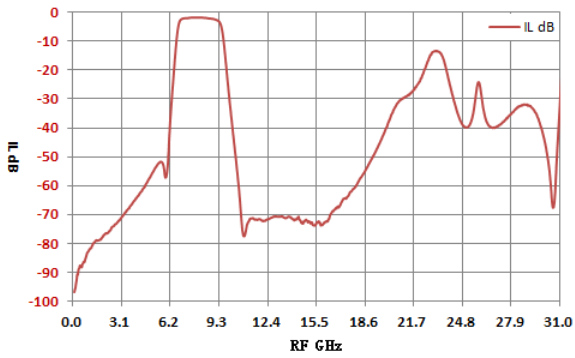
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



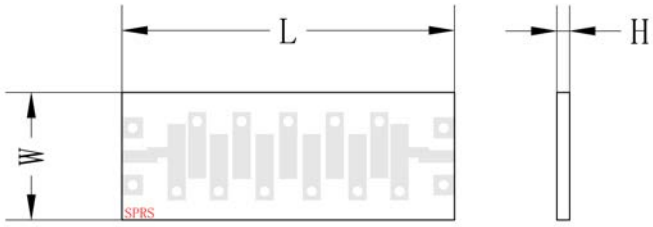
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	8.5	GHz
工作带宽	7.0-10.0	GHz
中心损耗	1.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-5.6GHz	dBc
带外抑制	40@11.4-20.0GHz	dBc

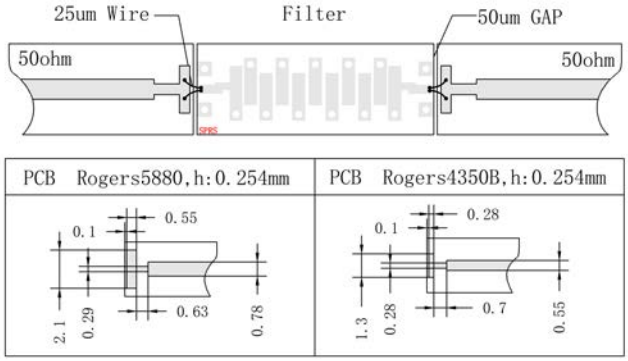
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



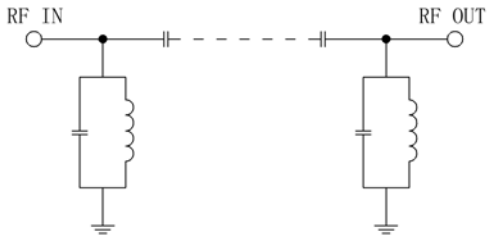
推荐装配图



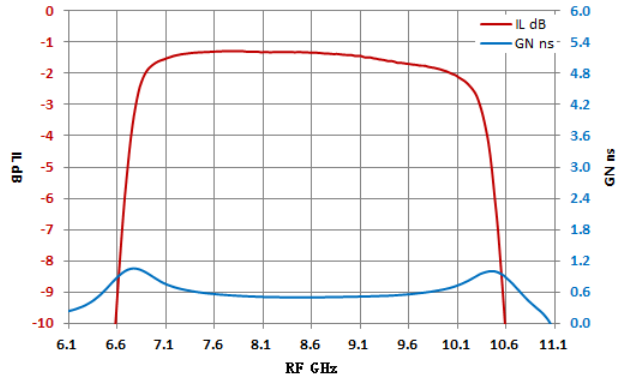
注意事项

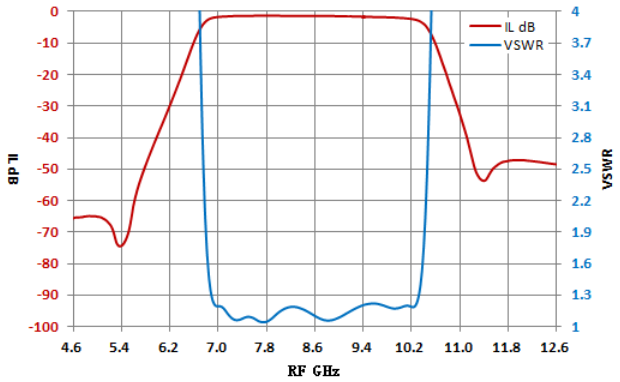
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

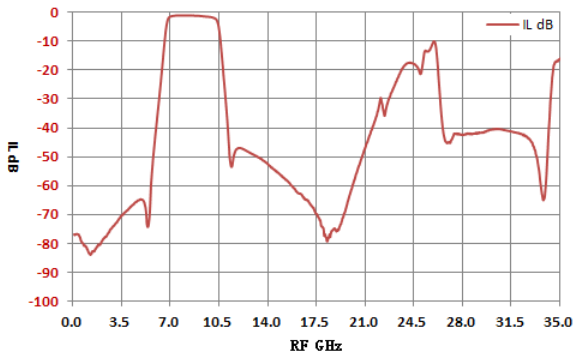
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

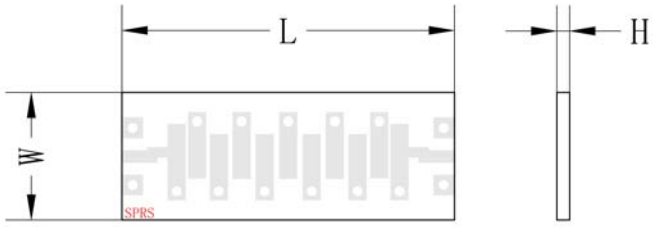
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.7	GHz
工作带宽	7.0-12.4	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-5.4GHz	dBc
带外抑制	40@14.2-22.0GHz	dBc

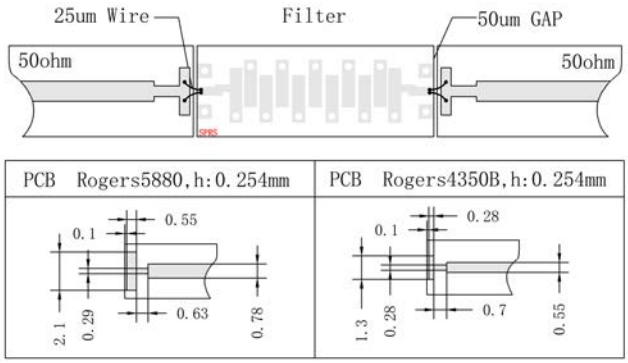
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



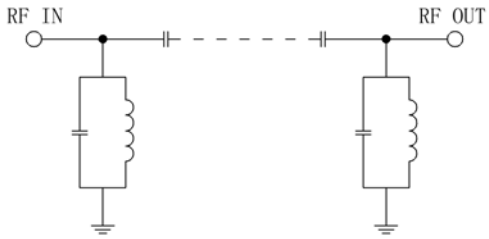
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

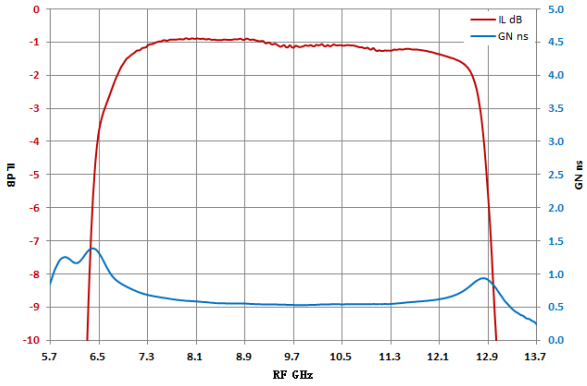
参考实物图

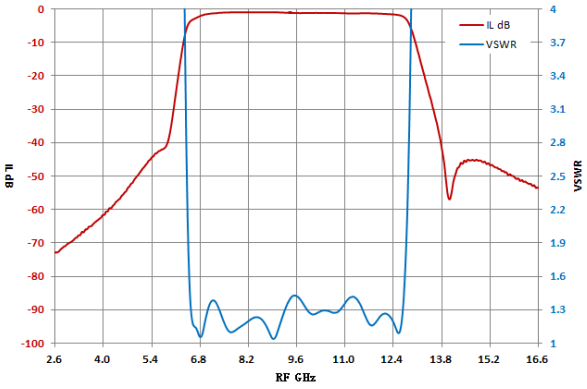


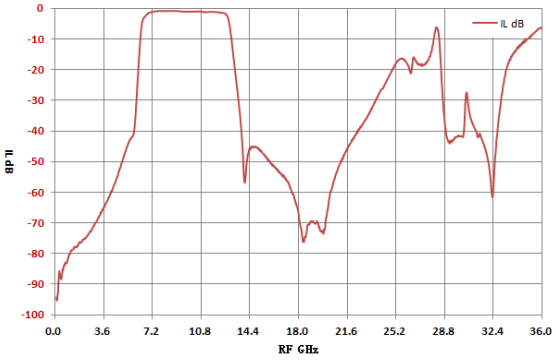
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



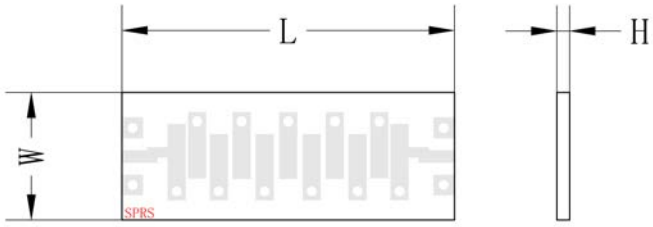
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.5	GHz
工作带宽	7.0-13.0	GHz
中心损耗	2.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-5.5GHz	dBc
带外抑制	30@15.0-22.0GHz	dBc

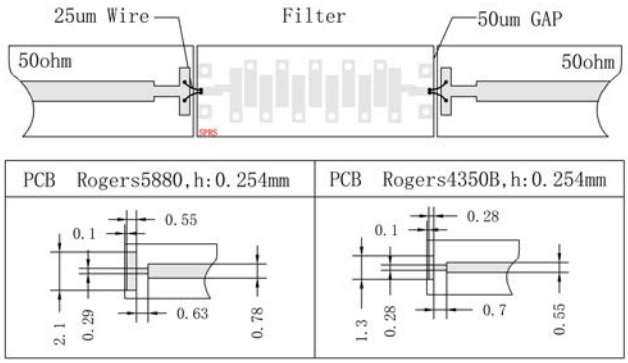
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



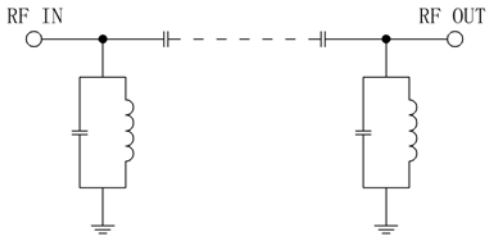
推荐装配图



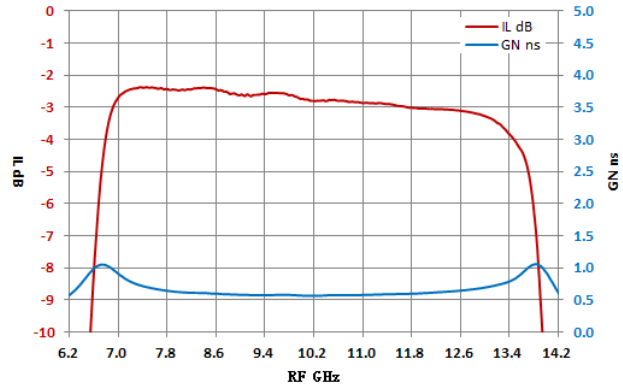
注意事项

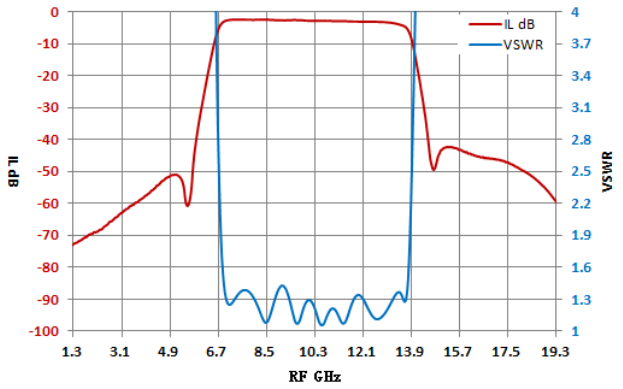
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

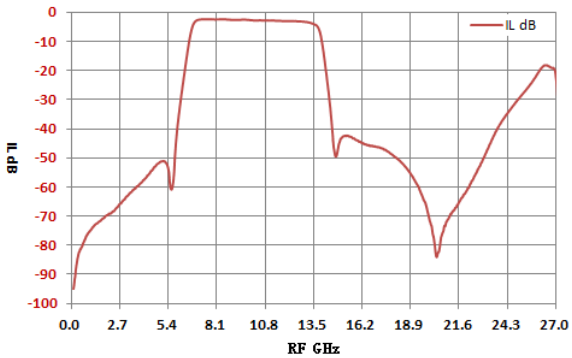
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

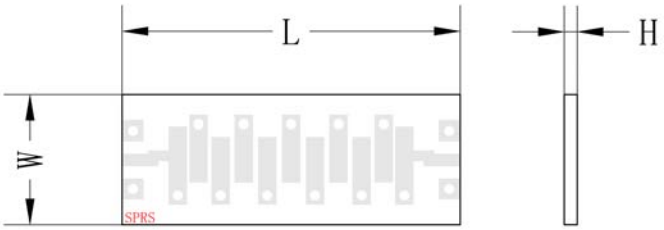
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	13.7	GHz
工作带宽	7.0-20.4	GHz
中心损耗	1.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.8:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-5.0GHz	dBc
带外抑制	40@24.2-27.5GHz	dBc

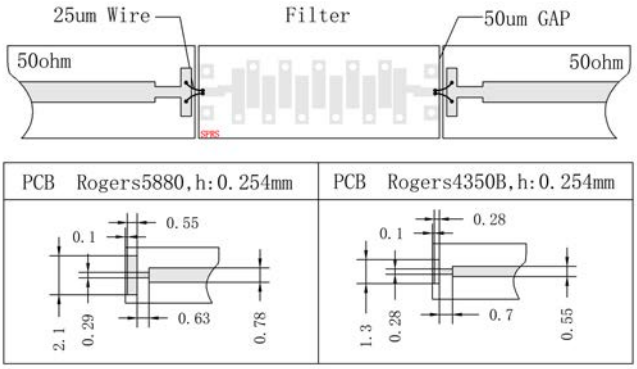
其它要求：设计保证

承受功率	0.5W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：7.0，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

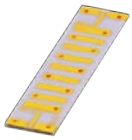
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

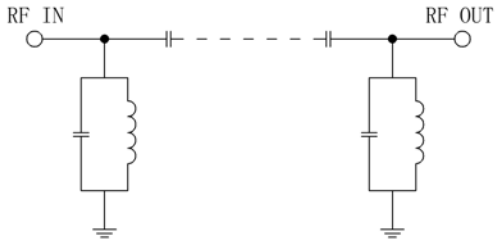
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

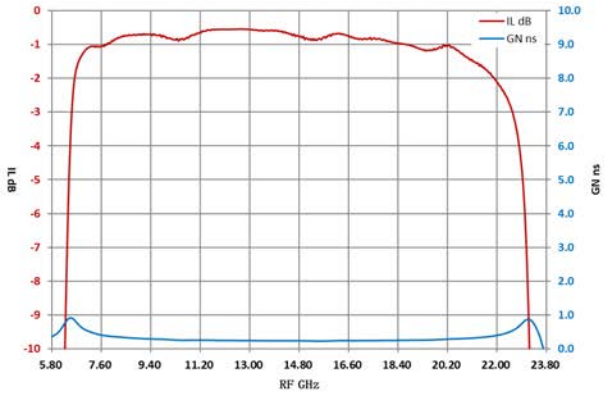
参考图

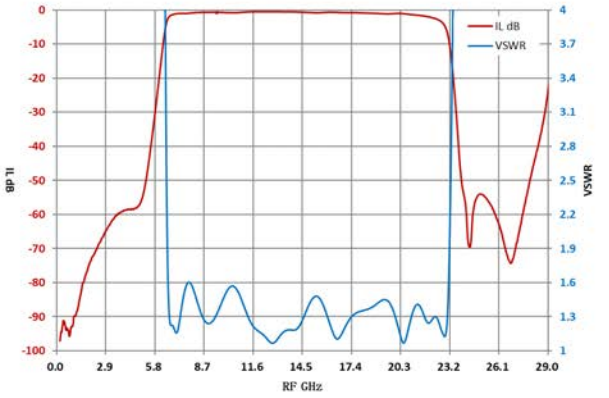


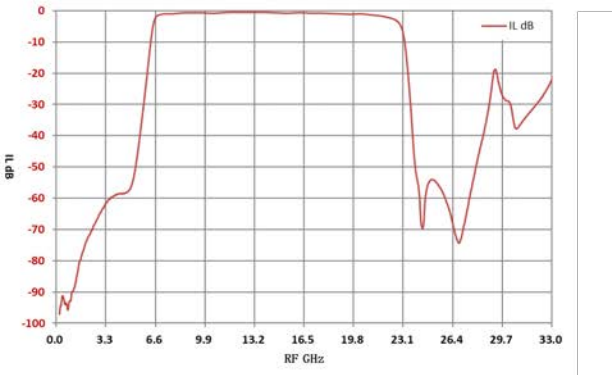
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



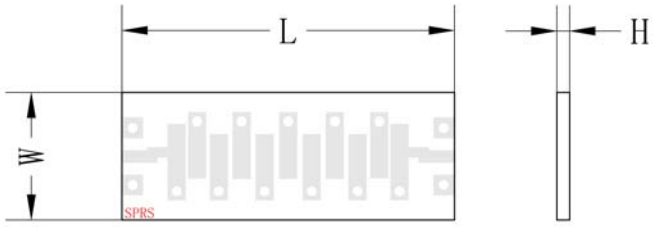
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	7.2	GHz
工作带宽	7.1-7.3	GHz
中心损耗	5.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-6.3GHz	dBc
带外抑制	40@7.8-19.0GHz	dBc

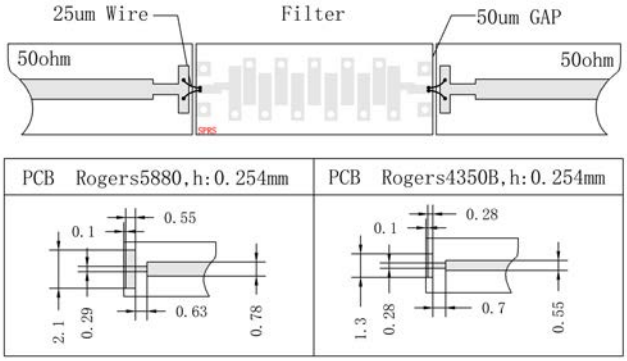
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.0，W：5.0，h：0.26

外形图：端口居中



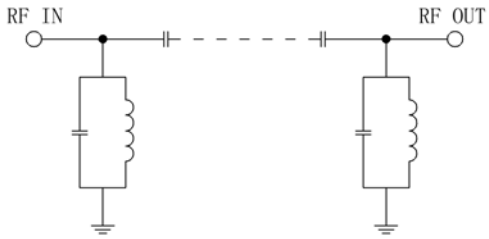
推荐装配图



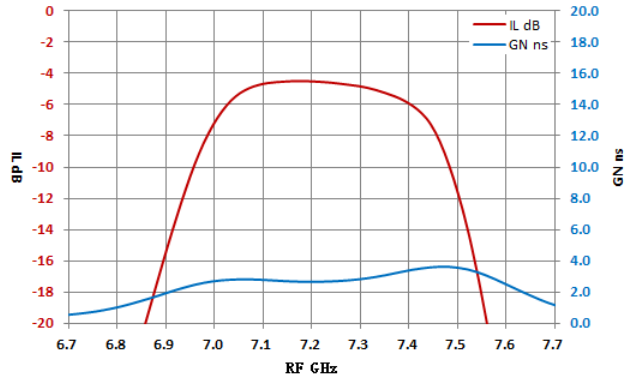
注意事项

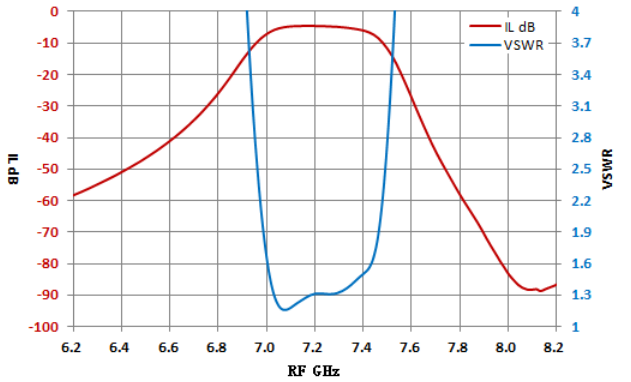
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

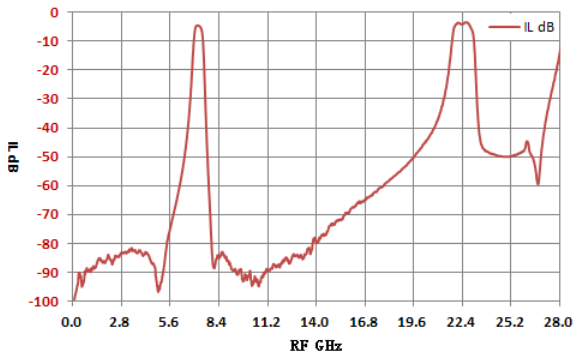
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



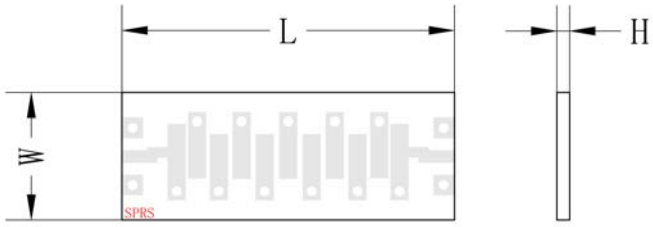
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	7.7	GHz
工作带宽	7.2-8.2	GHz
中心损耗	2.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-6.3GHz	dBc
带外抑制	40@9.3-17.0GHz	dBc

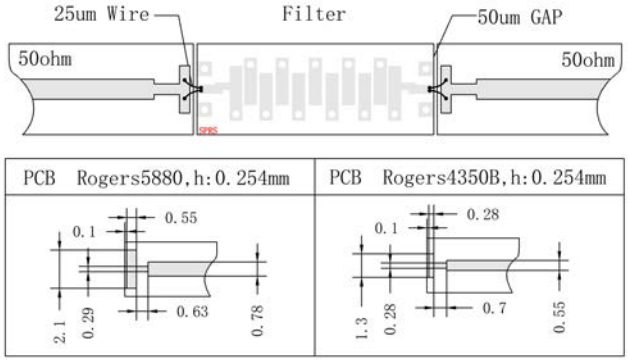
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：4.5，h：0.26

外形图：端口居中



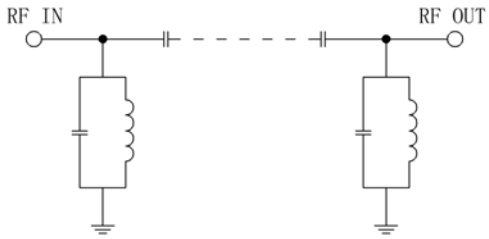
推荐装配图



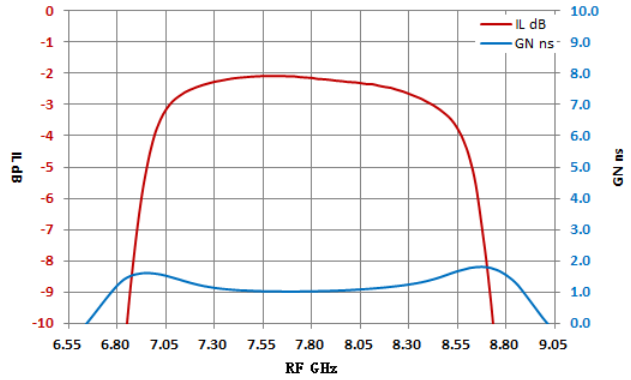
注意事项

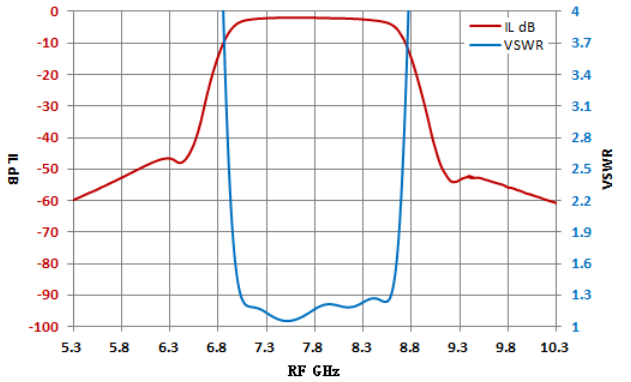
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

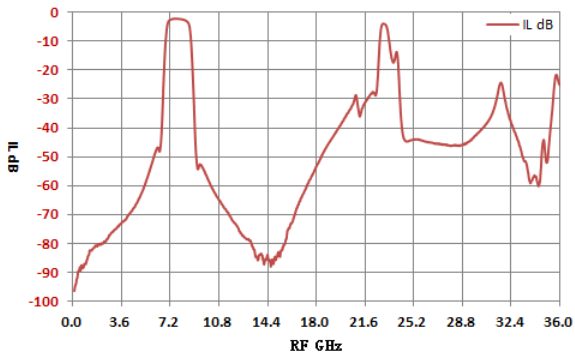
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



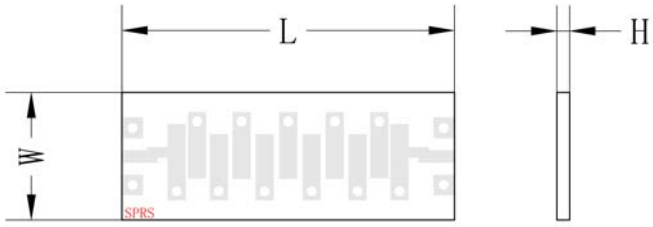
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	8.8	GHz
工作带宽	7.2-10.4	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-6.0GHz	dBc
带外抑制	40@12.3-21.0GHz	dBc

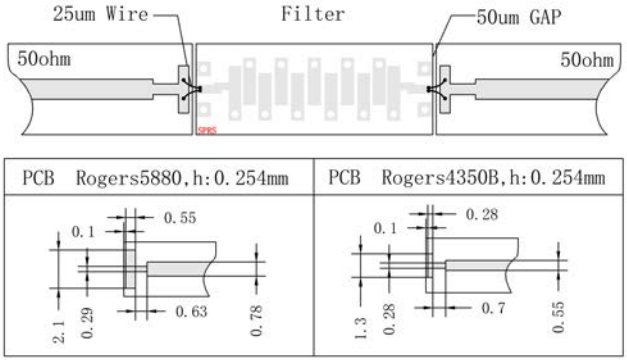
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.2，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



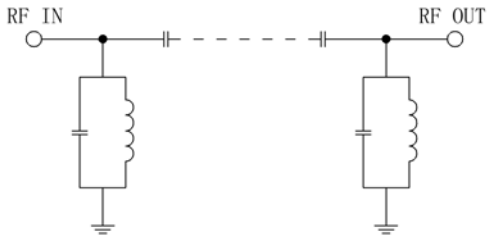
推荐装配图



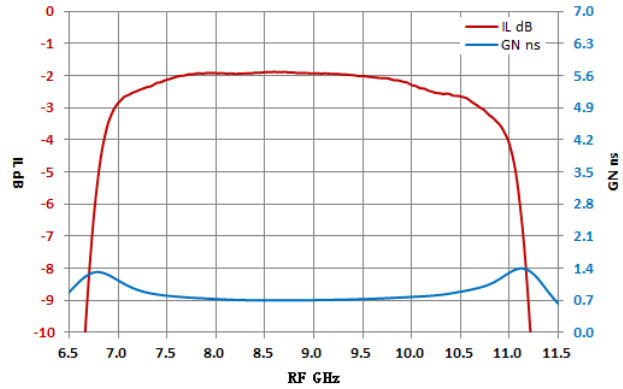
注意事项

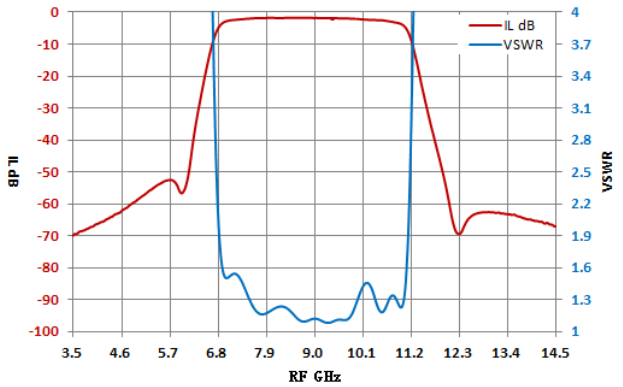
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

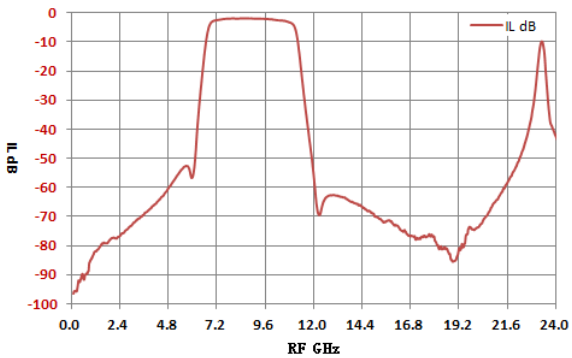
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



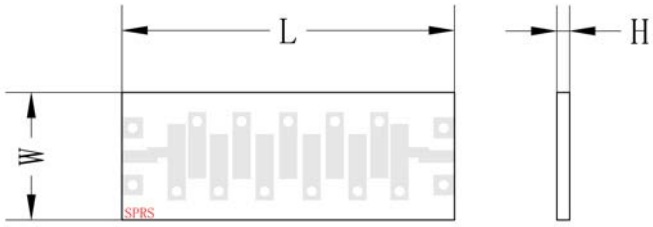
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	7.7	GHz
工作带宽	7.3-8.0	GHz
中心损耗	2.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-6.5GHz	dBc
带外抑制	40@9.0-18.0GHz	dBc

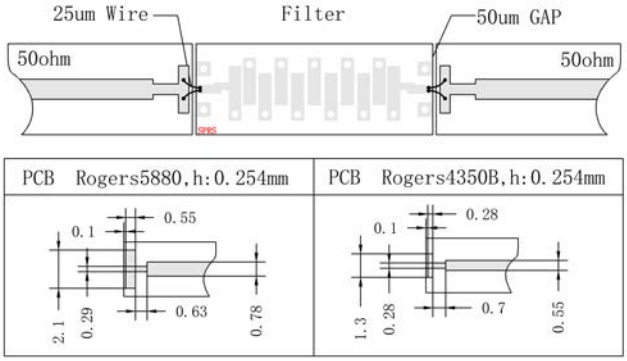
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：4.5，h：0.26

外形图：端口居中



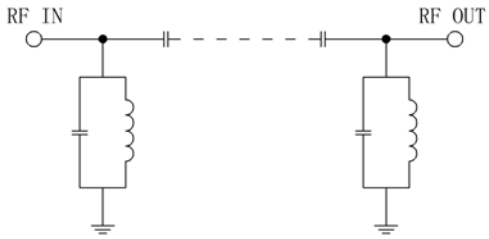
推荐装配图



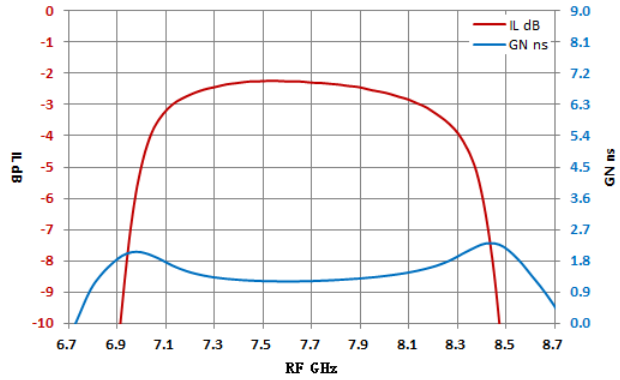
注意事项

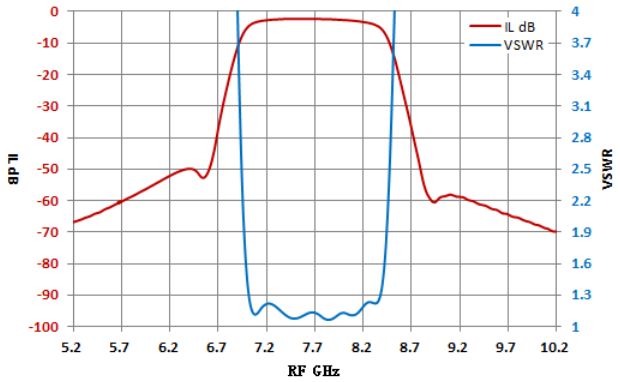
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

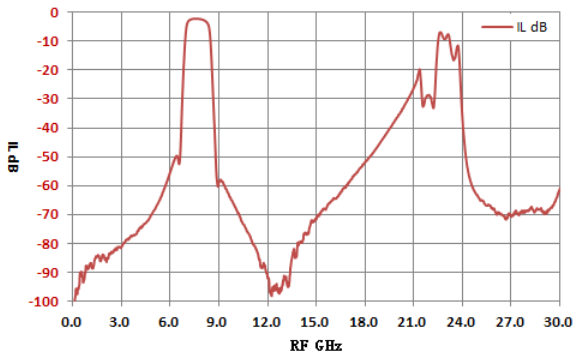
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

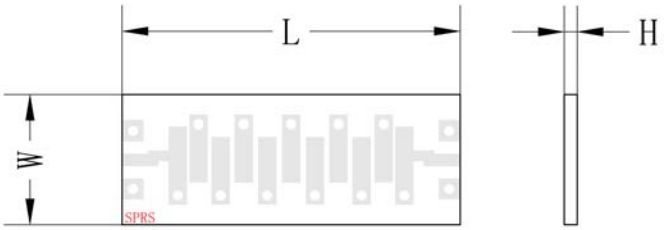
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	8.05	GHz
工作带宽	7.3-8.8	GHz
中心损耗	2.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-6.5GHz	dBc
带外抑制	35@9.6-17.0GHz	dBc

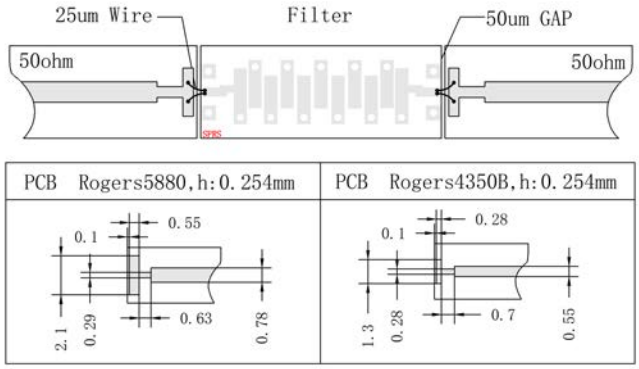
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：7.0，W：4.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

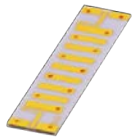
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

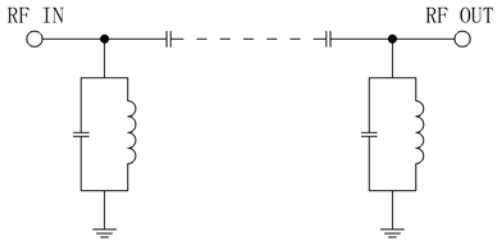
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

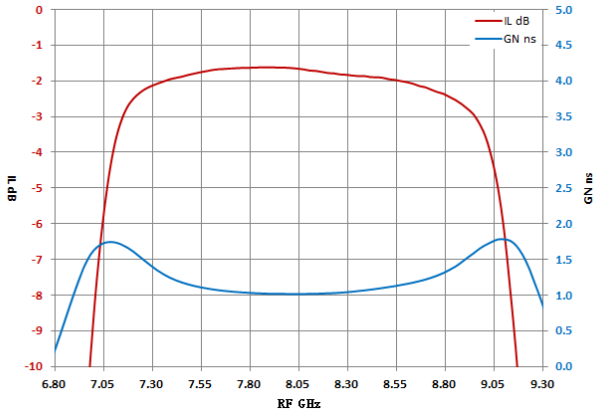
参考图

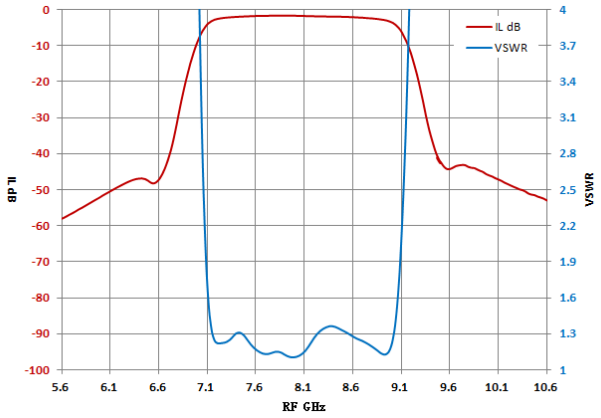


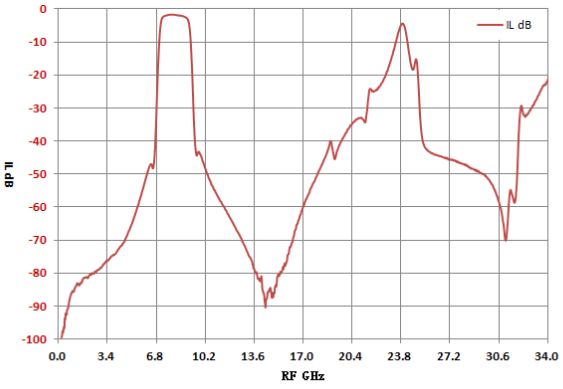
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



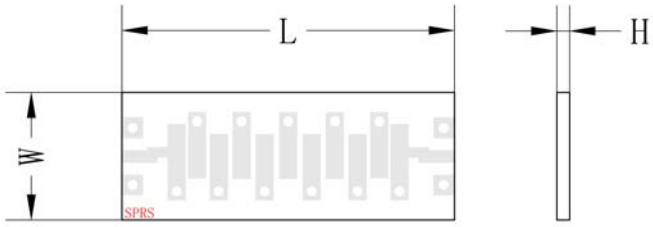
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	8.2	GHz
工作带宽	7.3-9.1	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.6	ns
带外抑制	40@DC-6.2GHz	dBc
带外抑制	40@10.5-18.0GHz	dBc

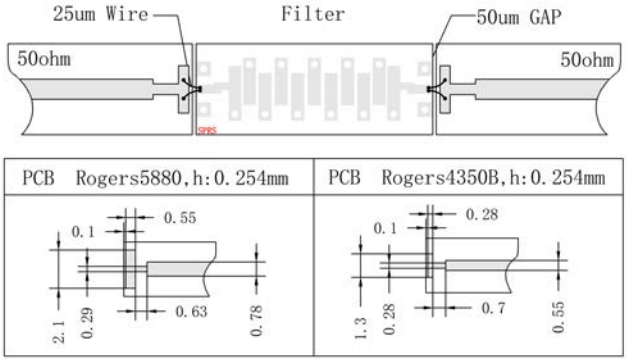
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：4.5，h：0.26

外形图：端口居中



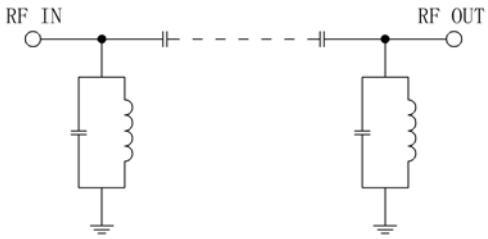
推荐装配图



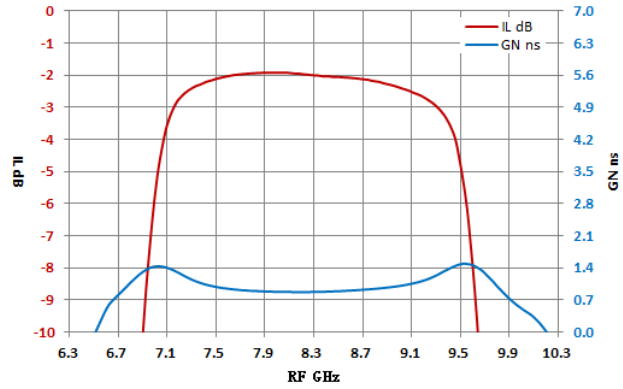
注意事项

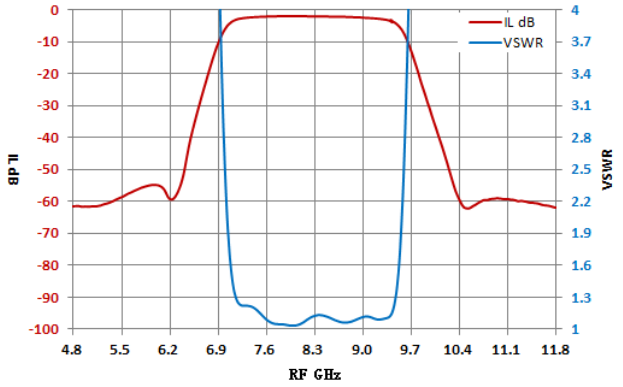
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

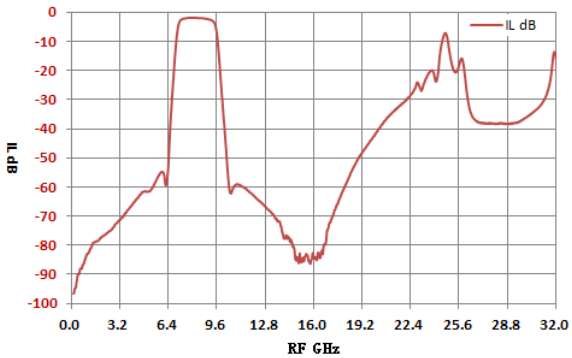
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



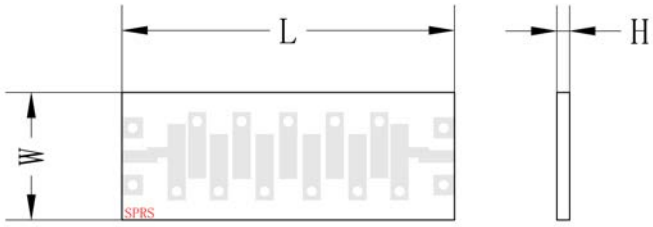
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	8.0	GHz
工作带宽	7.4-8.6	GHz
中心损耗	2.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.6	ns
带外抑制	40@DC-6.0GHz	dBc
带外抑制	40@10.4-15.0GHz	dBc

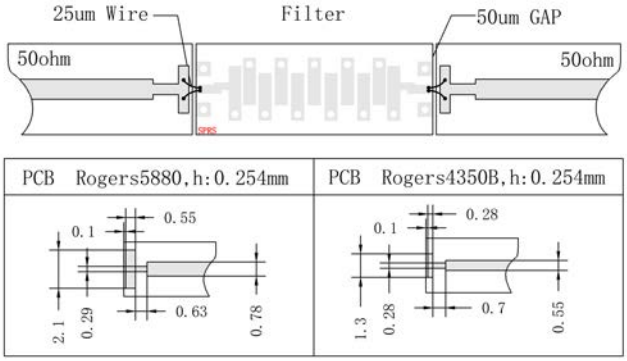
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：4.5，h：0.26

外形图：端口居中



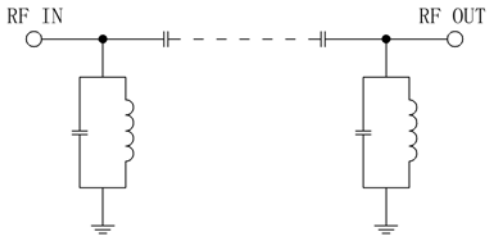
推荐装配图



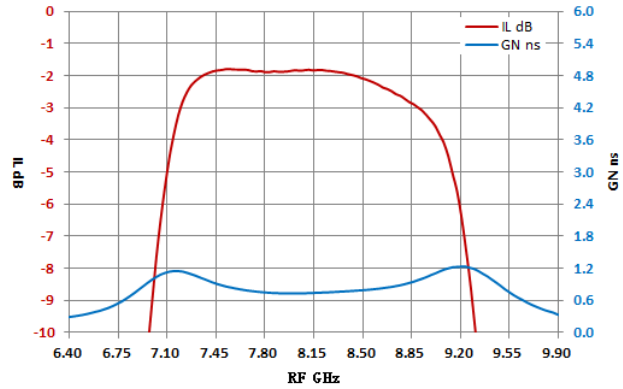
注意事项

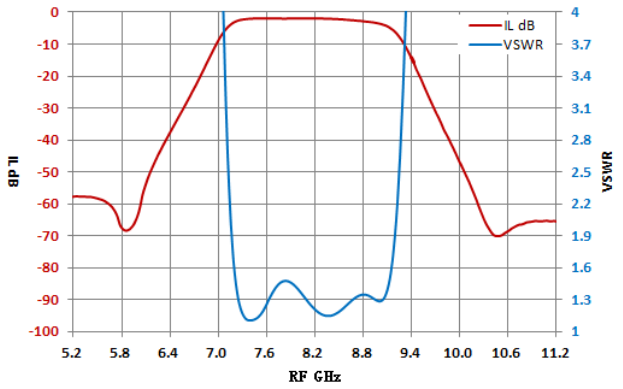
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

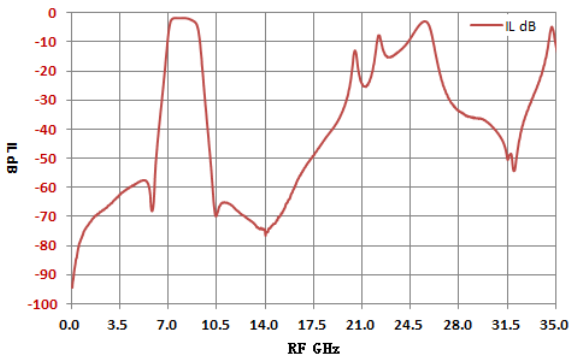
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

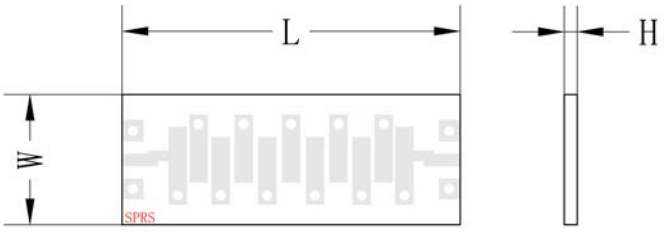
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.6	GHz
工作带宽	7.4-11.8	GHz
中心损耗	1.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.8:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	15@DC-6.1GHz	dBc
带外抑制	10@14.0-20.0GHz	dBc
带外抑制	40@20.0-24.0GHz	dBc

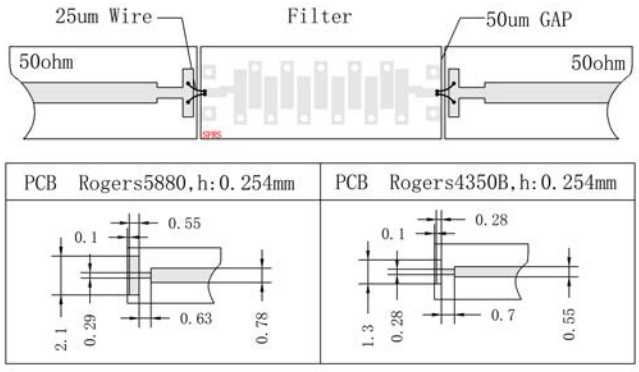
其它要求：设计保证

承受功率	0.5W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：7.0，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.74mm,端口可互换;

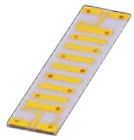
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

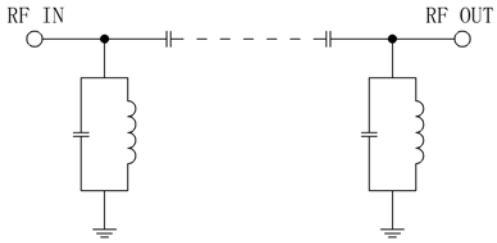
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

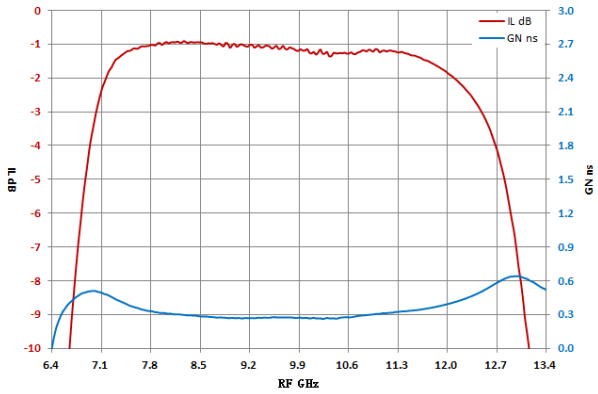
参考图

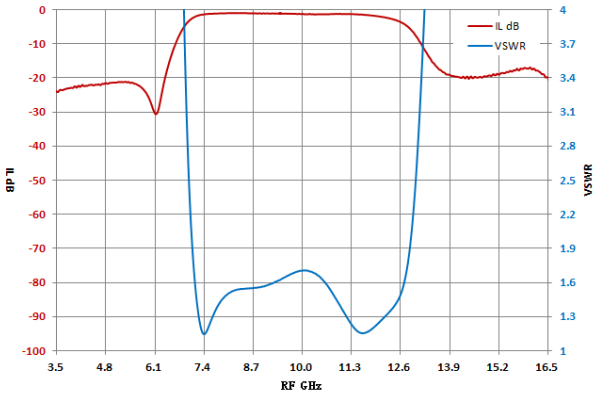


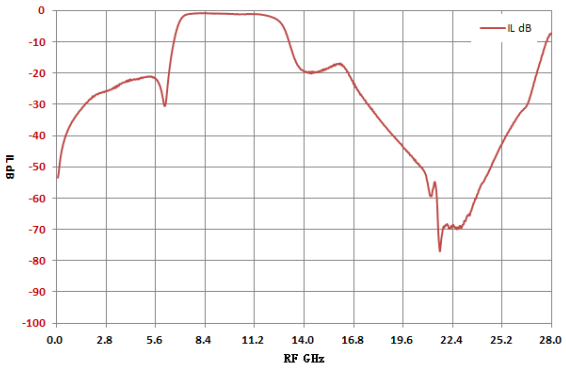
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

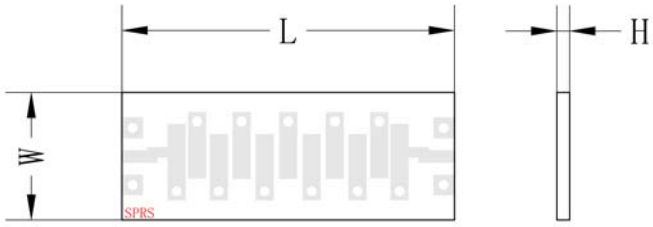
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	7.95	GHz
工作带宽	7.5-8.4	GHz
中心损耗	2.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-6.8GHz	dBc
带外抑制	40@9.2-19.0GHz	dBc

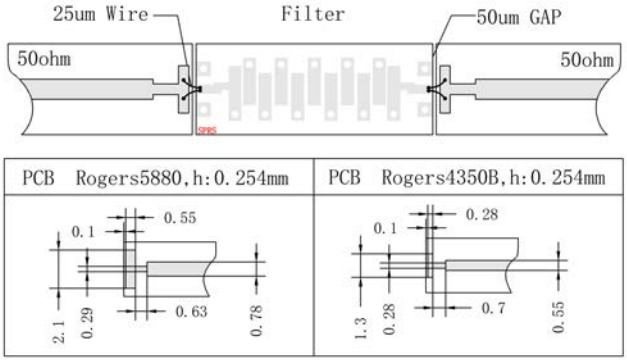
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：4.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



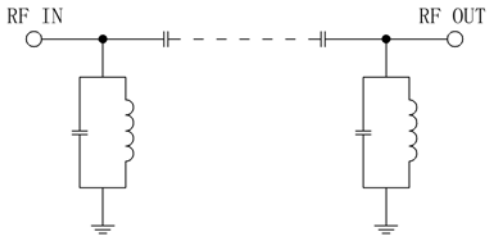
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

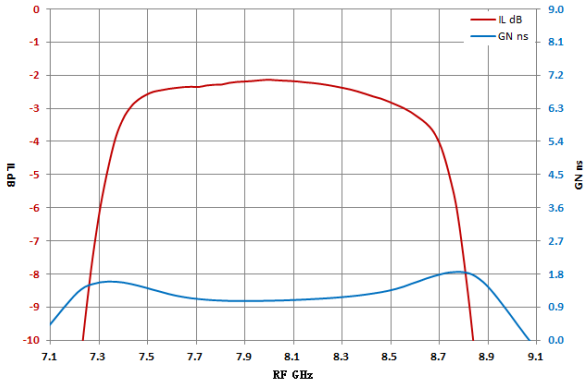
参考实物图

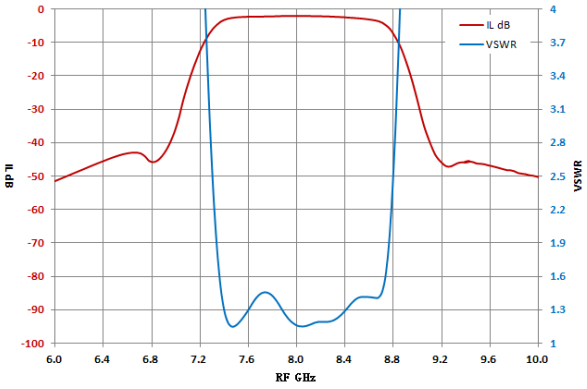


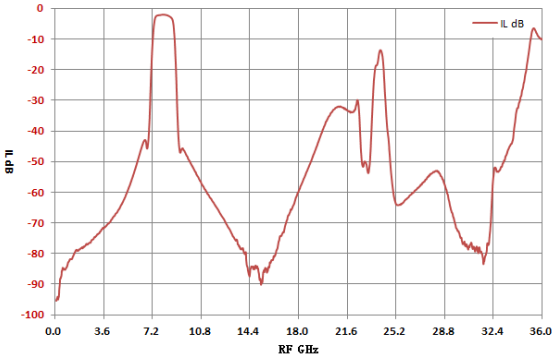
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



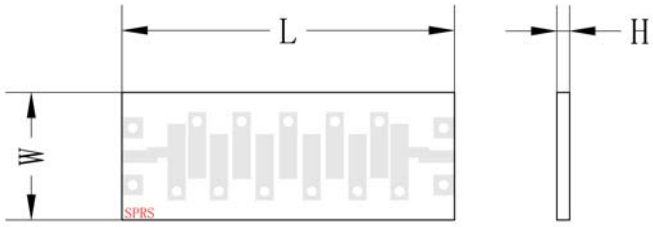
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.4	GHz
工作带宽	7.5-11.3	GHz
中心损耗	1.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-6.2GHz	dBc
带外抑制	40@13.5-22.0GHz	dBc

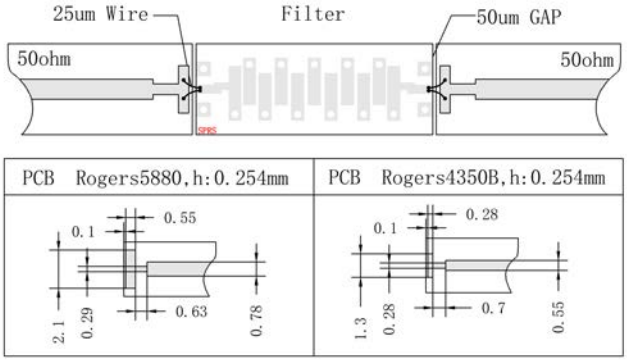
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



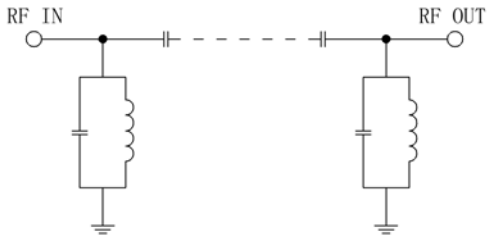
推荐装配图



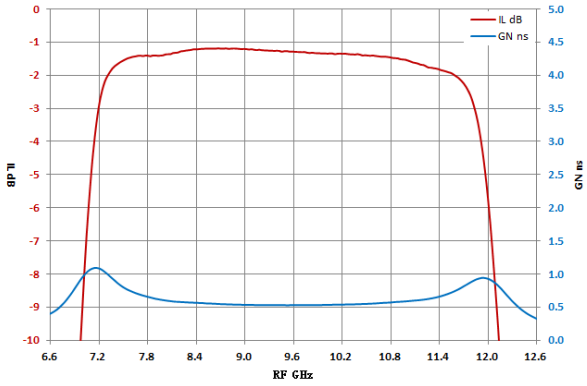
注意事项

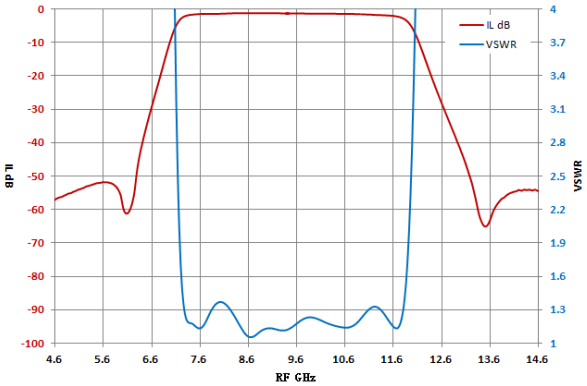
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

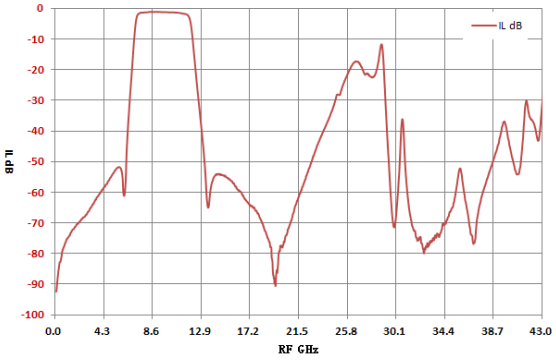
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

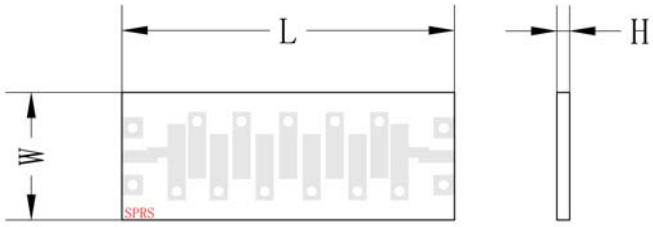
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.4	GHz
工作带宽	7.5-11.3	GHz
中心损耗	1.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-5.6GHz	dBc
带外抑制	40@13.3-24.0GHz	dBc

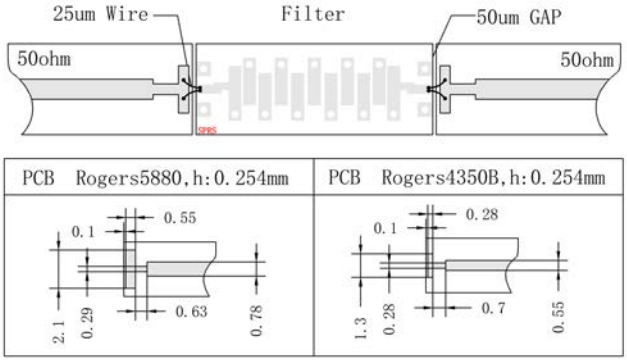
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.8，W：3.4，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



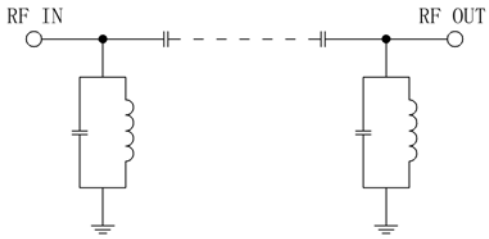
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

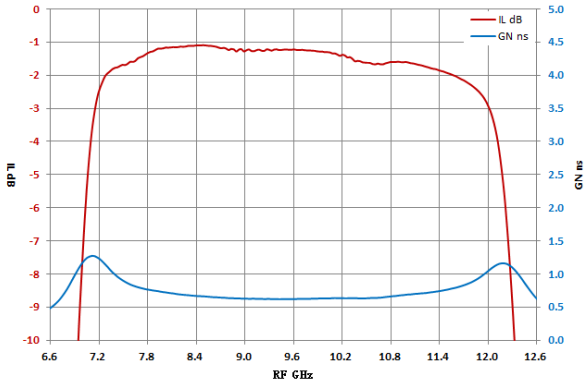
参考实物图

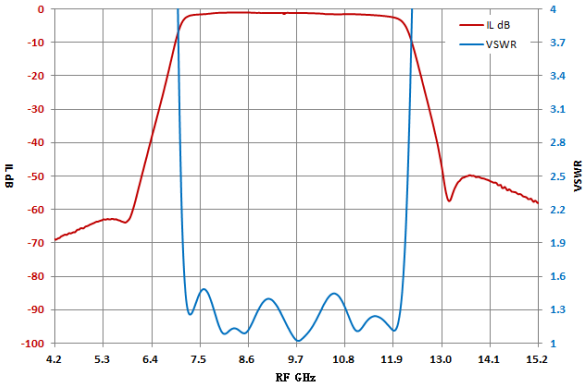


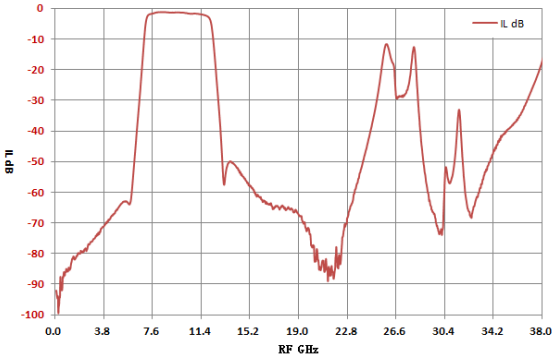
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

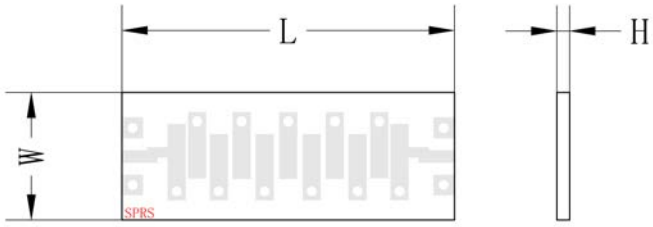
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.5	GHz
工作带宽	7.5-11.5	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-5.3GHz	dBc
带外抑制	40@13.4-24.0GHz	dBc

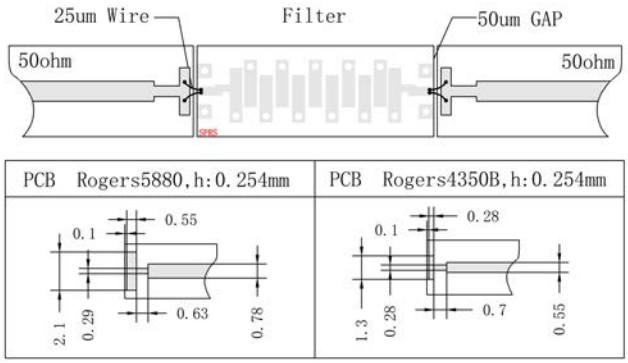
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：3.4，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



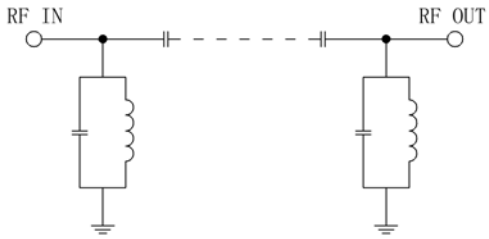
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

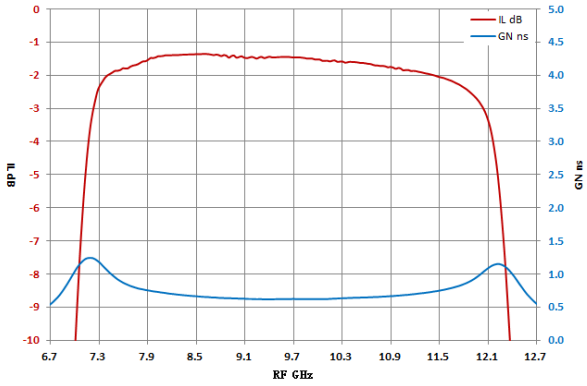
参考实物图

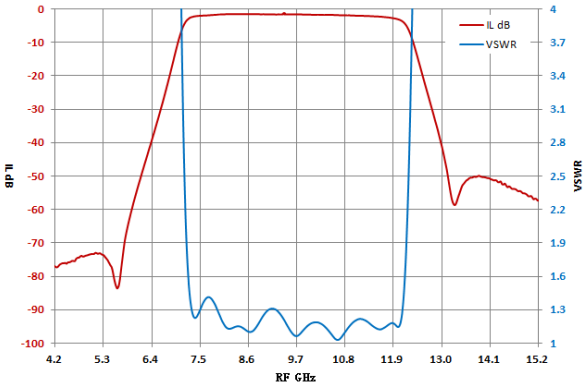


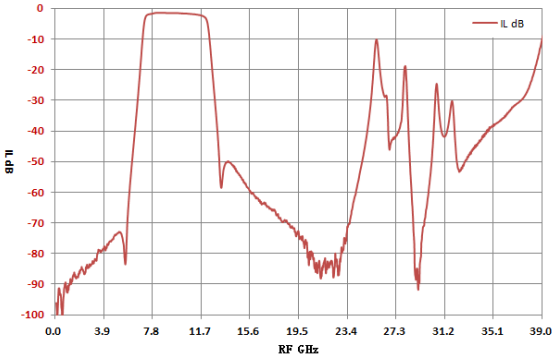
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

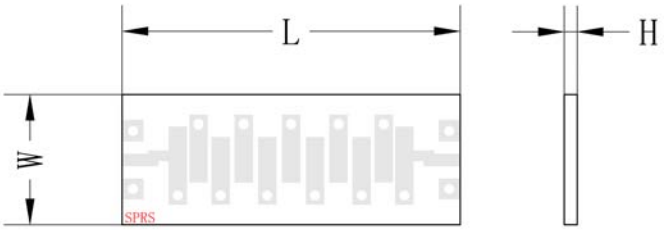
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.55	GHz
工作带宽	7.5-11.6	GHz
中心损耗	1.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.6	ns
带外抑制	65@DC-5.8GHz	dBc
带外抑制	45@13.5-23.0GHz	dBc

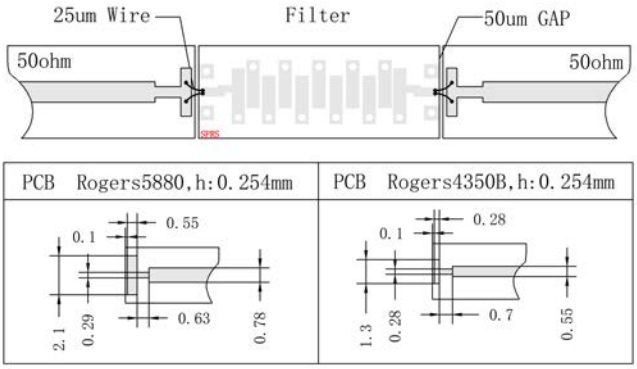
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：6.8，W：3.4，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

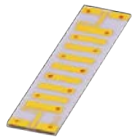
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

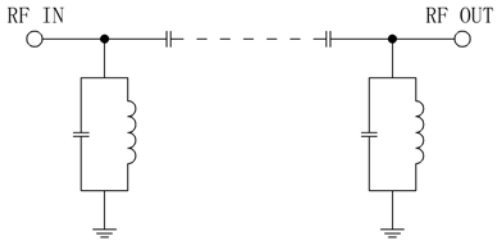
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

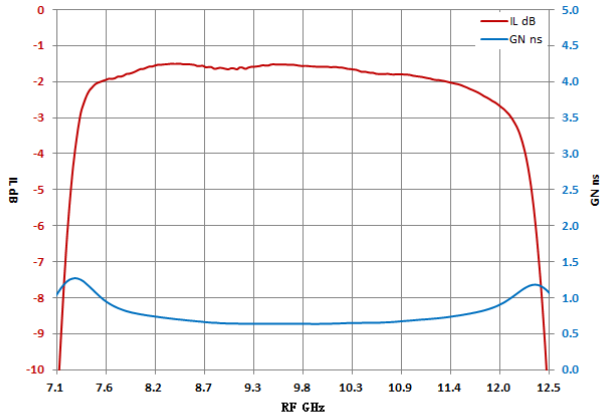
参考图

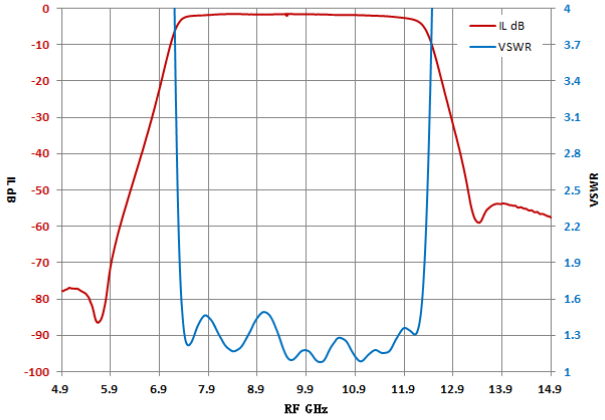


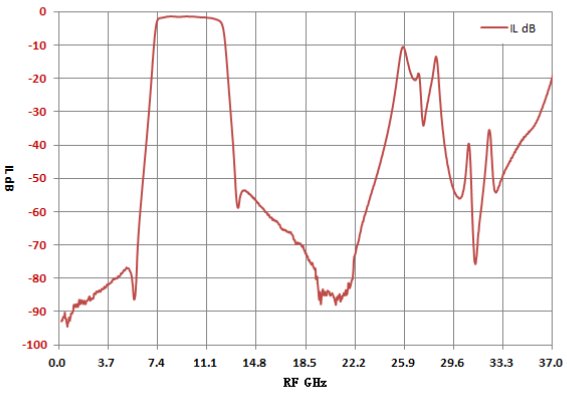
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



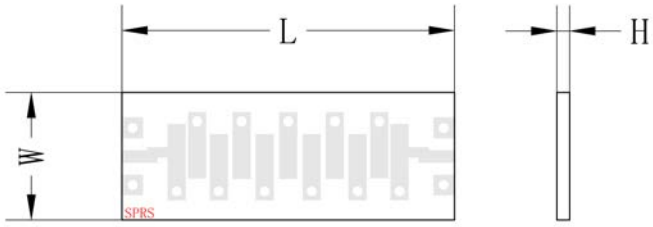
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	10.0	GHz
工作带宽	7.5-12.4	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	1.0	ns
带外抑制	40@DC-4.5GHz	dBc
带外抑制	40@14.5-23.0GHz	dBc

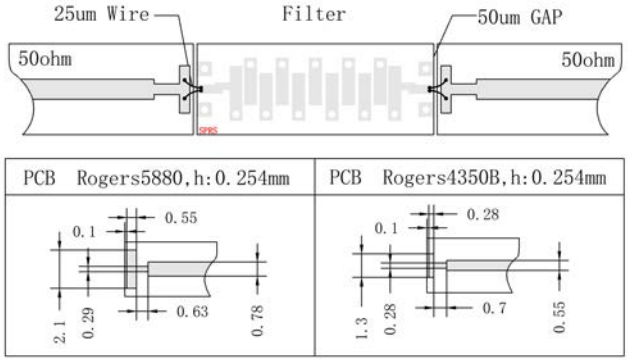
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



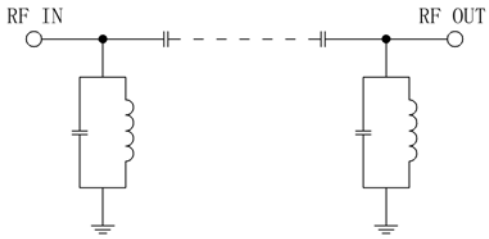
推荐装配图



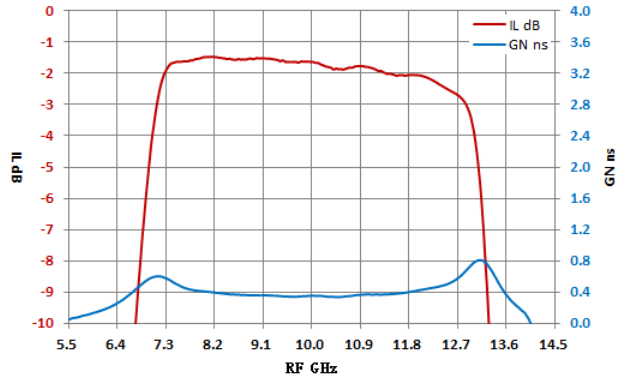
注意事项

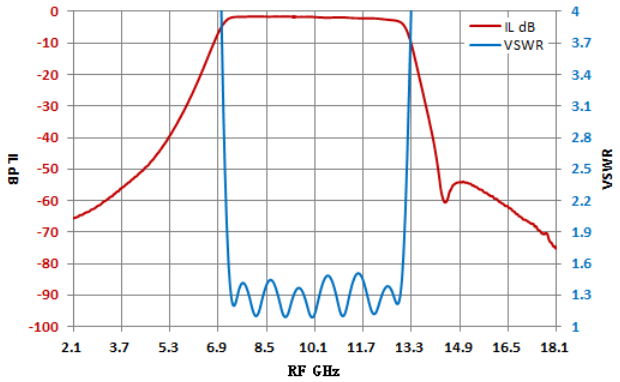
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

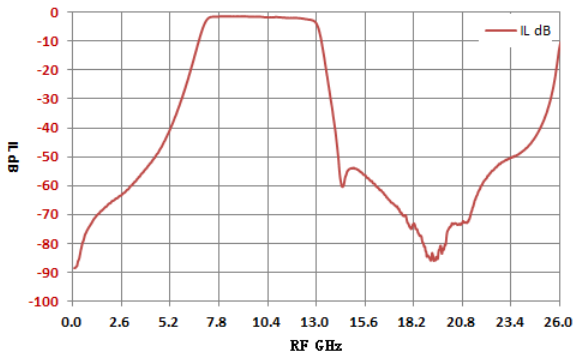
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



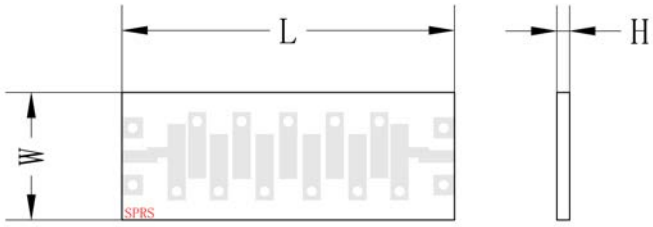
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	8.2	GHz
工作带宽	7.6-8.7	GHz
中心损耗	2.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-6.6GHz	dBc
带外抑制	40@10.0-19.0GHz	dBc

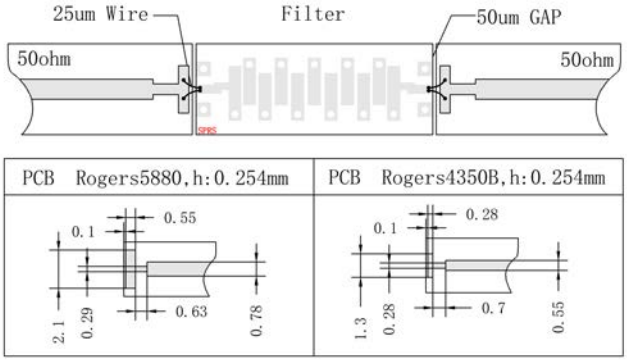
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：4.5，h：0.26

外形图：端口居中



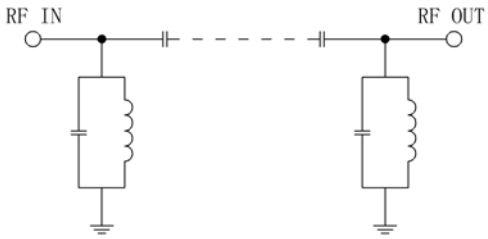
推荐装配图



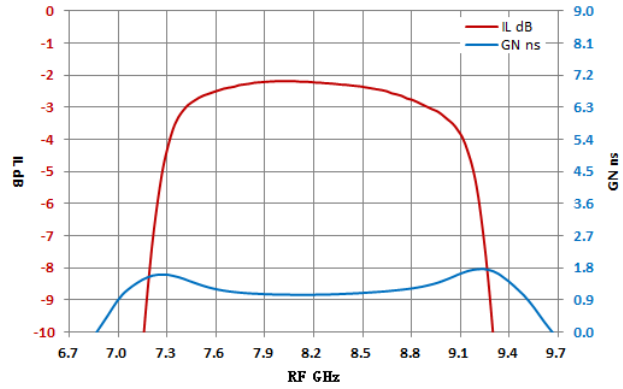
注意事项

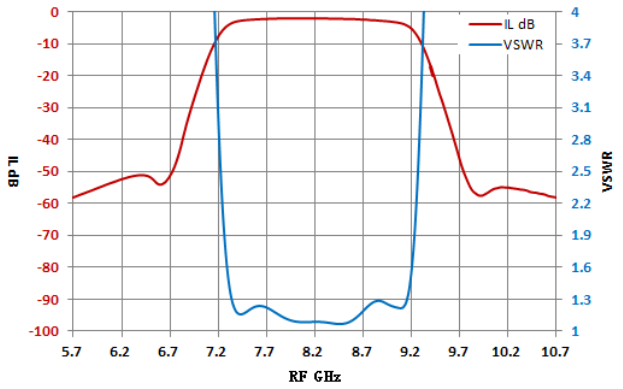
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

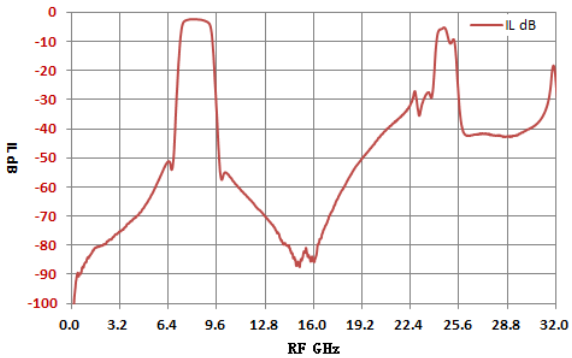
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



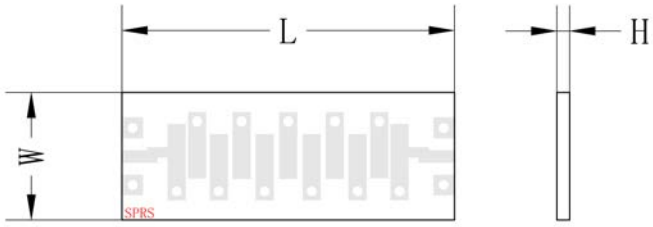
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	8.3	GHz
工作带宽	7.6-8.9	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	35@DC-6.6GHz	dBc
带外抑制	40@10.0-18.5GHz	dBc

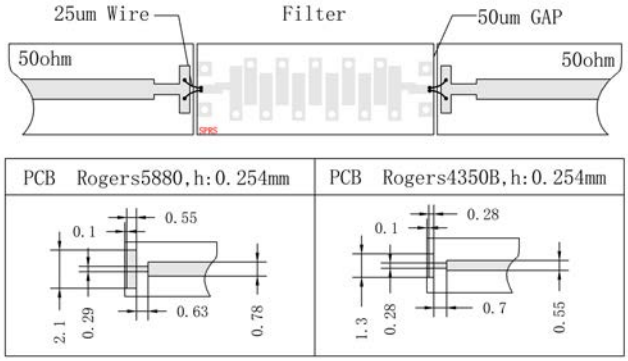
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：4.5，h：0.26

外形图：端口居中



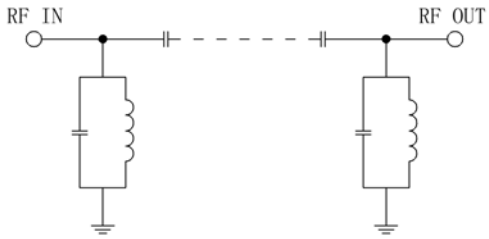
推荐装配图



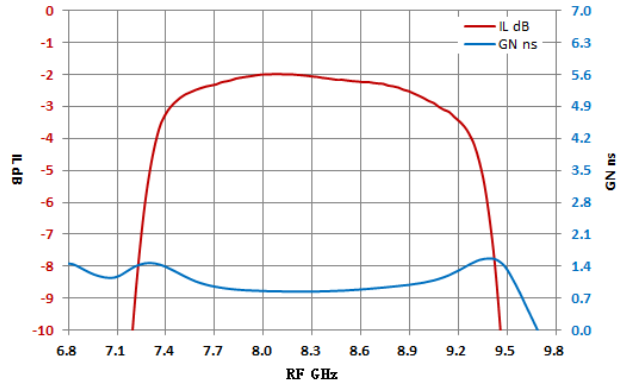
注意事项

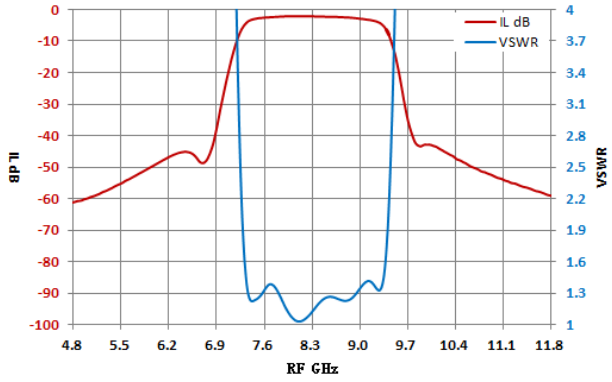
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

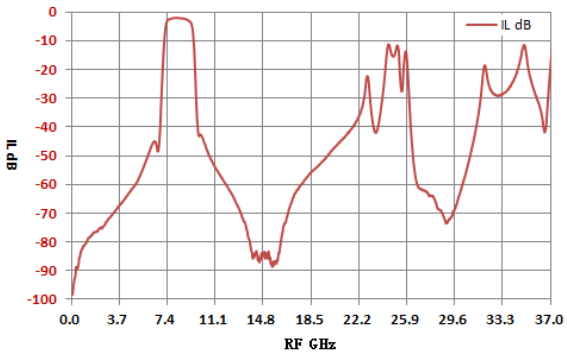
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



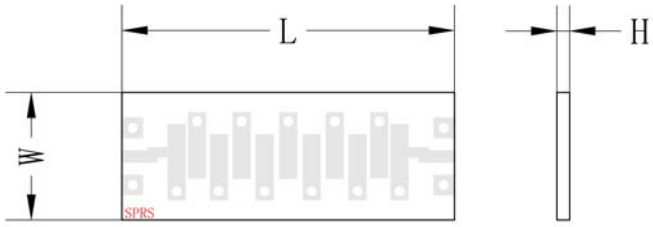
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	8.3	GHz
工作带宽	7.6-9.0	GHz
中心损耗	2.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	35@DC-6.5GHz	dBc
带外抑制	35@10.2-19.0GHz	dBc

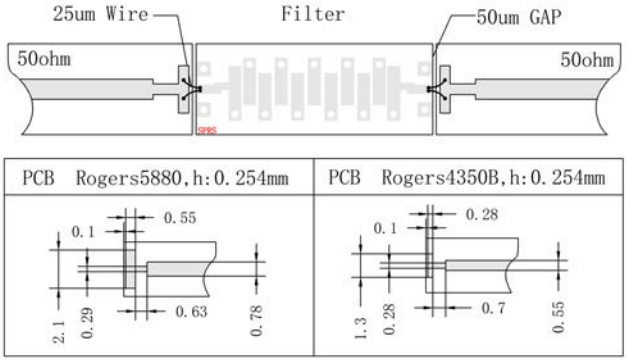
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：4.5，h：0.26

外形图：端口居中



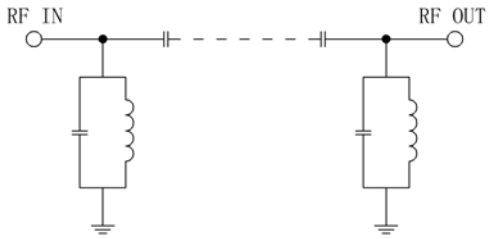
推荐装配图



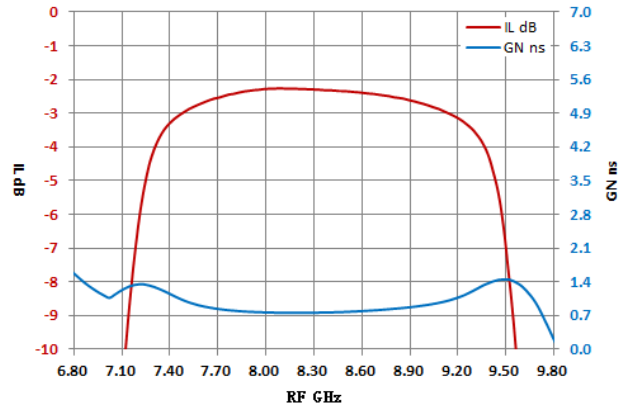
注意事项

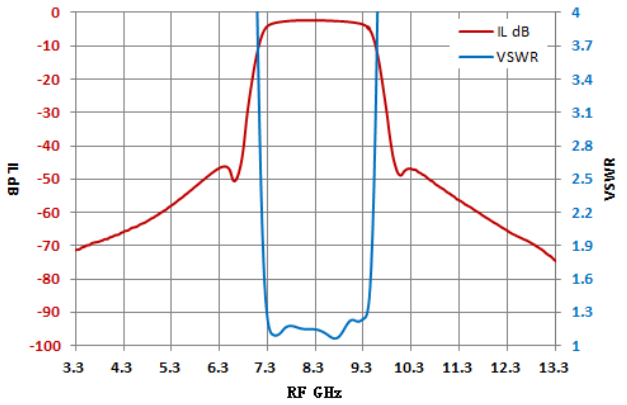
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

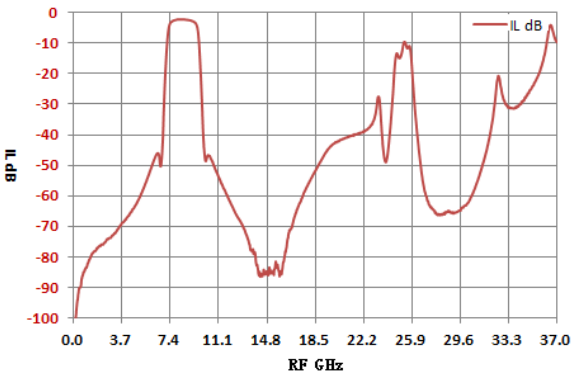
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

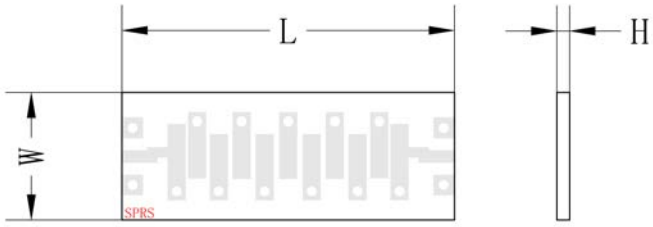
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.25	GHz
工作带宽	7.6-10.9	GHz
中心损耗	2.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-5.1GHz	dBc
带外抑制	40@12.2-19.0GHz	dBc

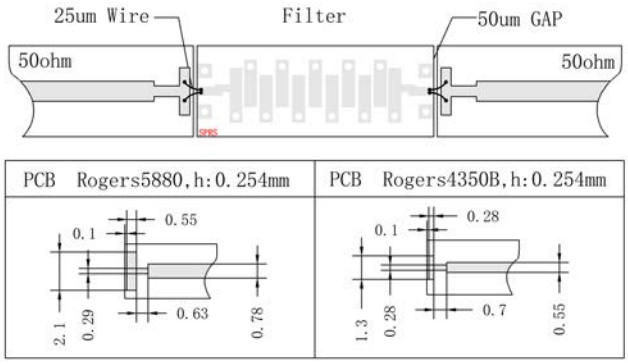
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



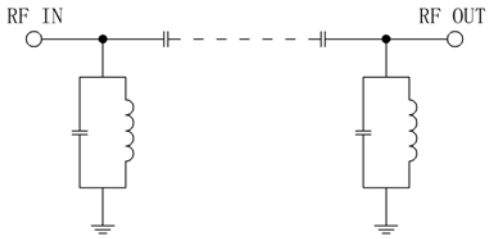
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

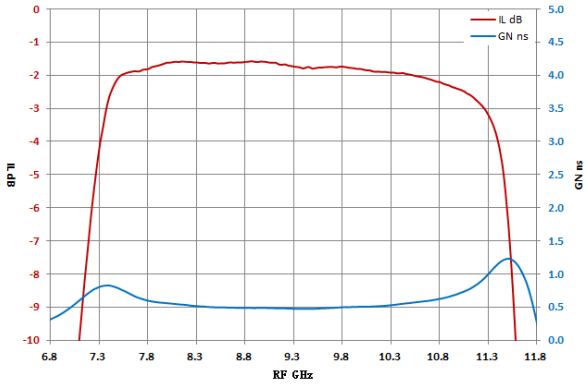
参考实物图

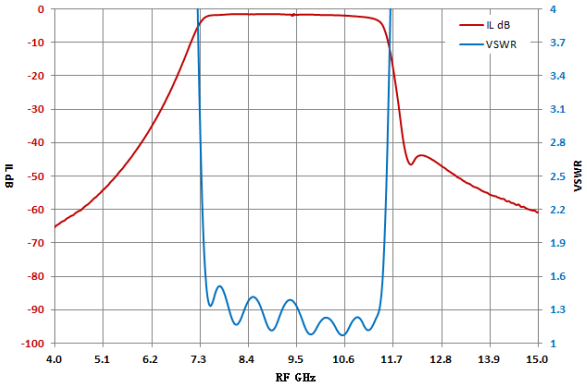


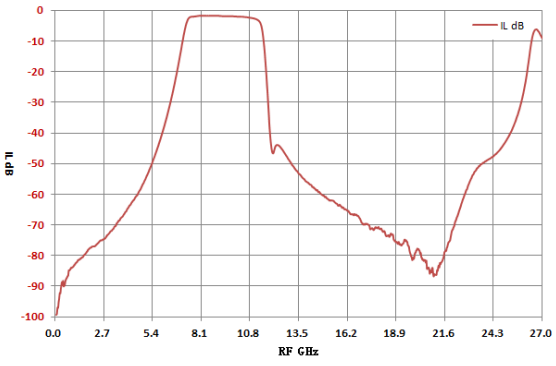
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



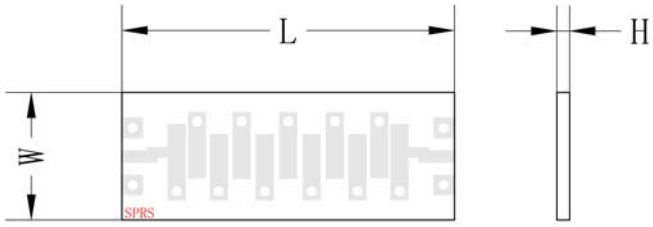
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	10.4	GHz
工作带宽	7.6-13.2	GHz
中心损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-5.6GHz	dBc
带外抑制	40@15.4-26.0GHz	dBc

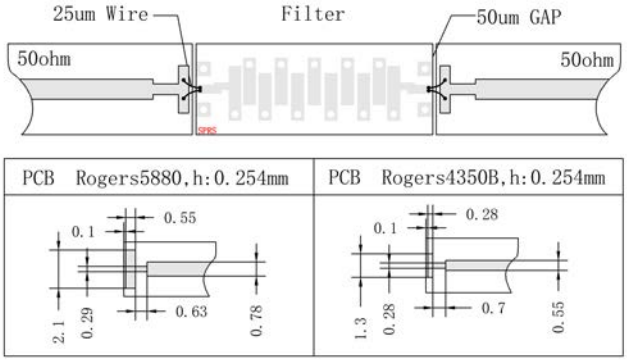
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



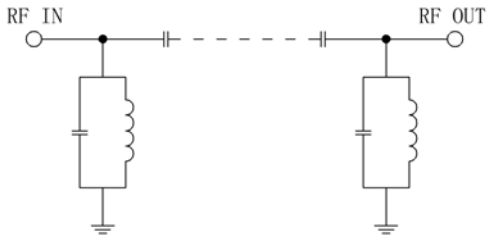
推荐装配图



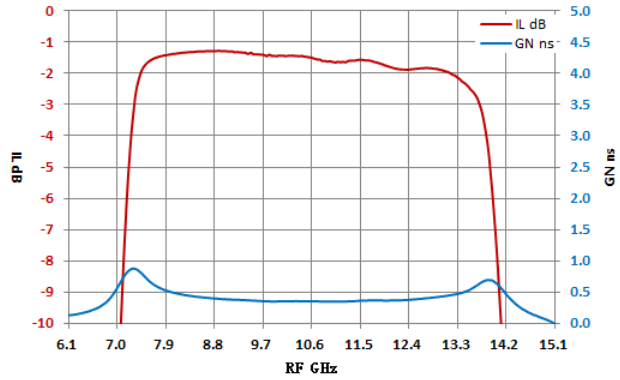
注意事项

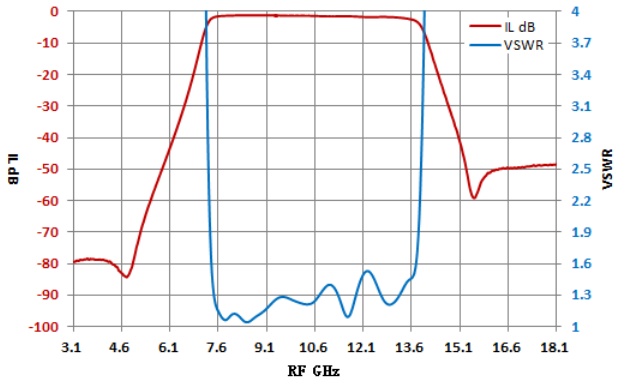
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

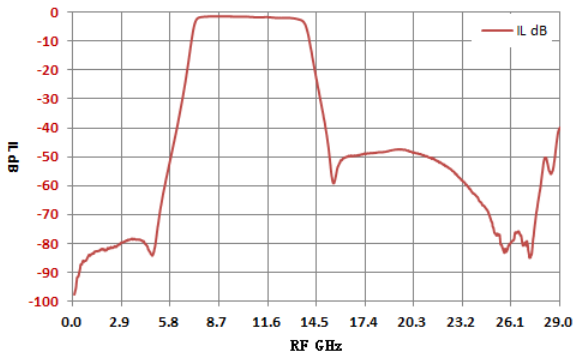
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



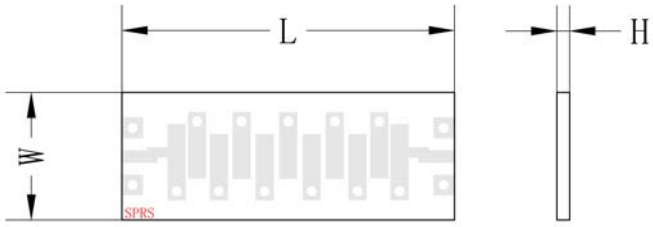
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	8.4	GHz
工作带宽	7.7-9.0	GHz
中心损耗	3.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-6.0GHz	dBc
带外抑制	40@10.2-19.0GHz	dBc

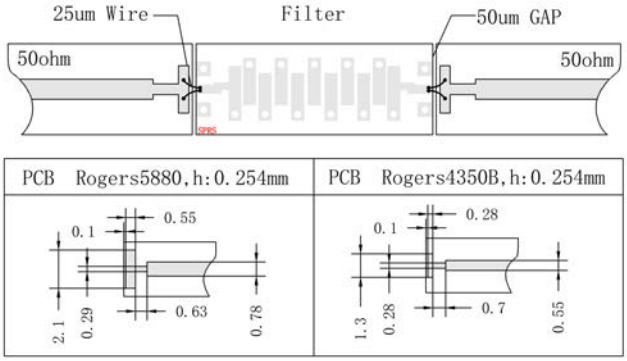
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



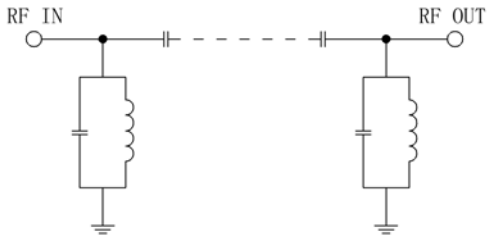
推荐装配图



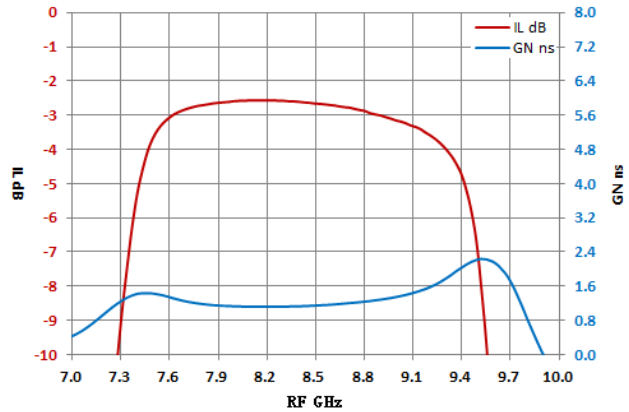
注意事项

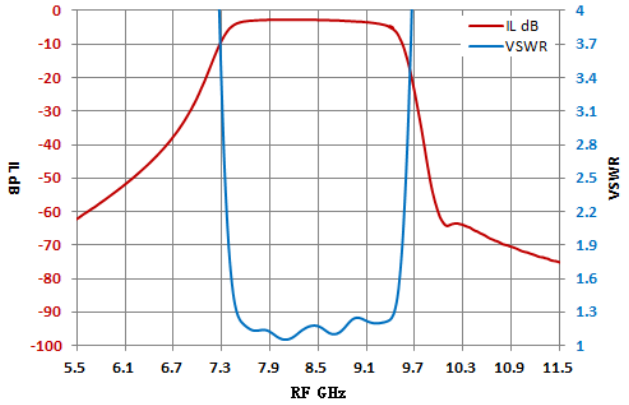
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

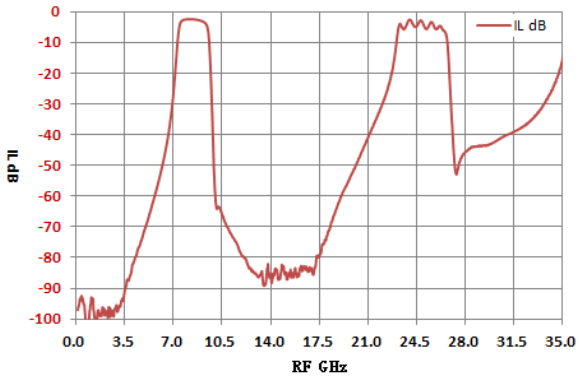
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



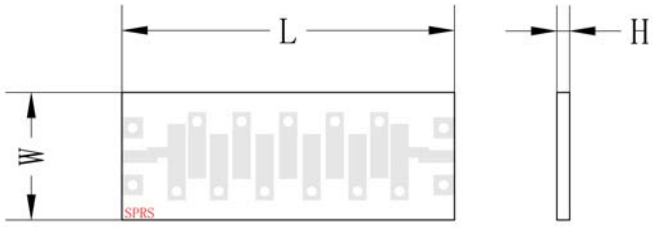
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.0	GHz
工作带宽	7.7-10.3	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-6.4GHz	dBc
带外抑制	40@12.0-20.0GHz	dBc

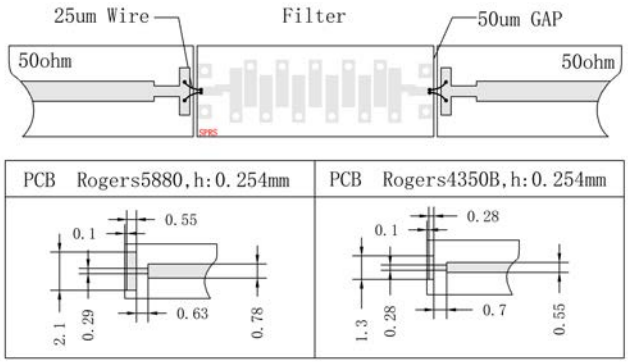
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



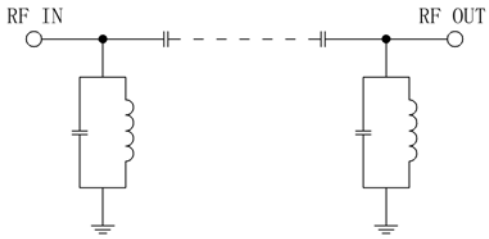
推荐装配图



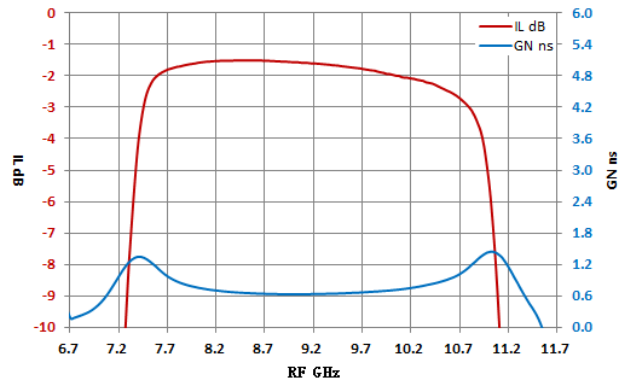
注意事项

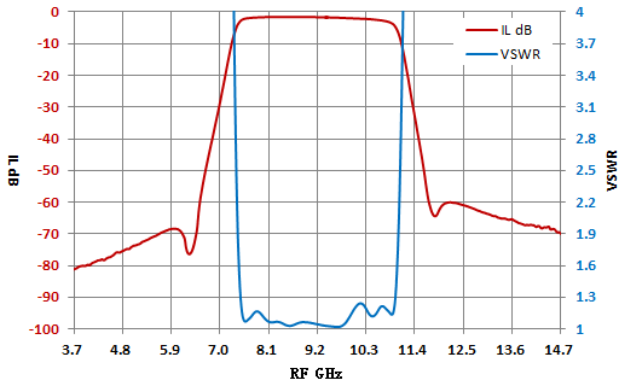
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

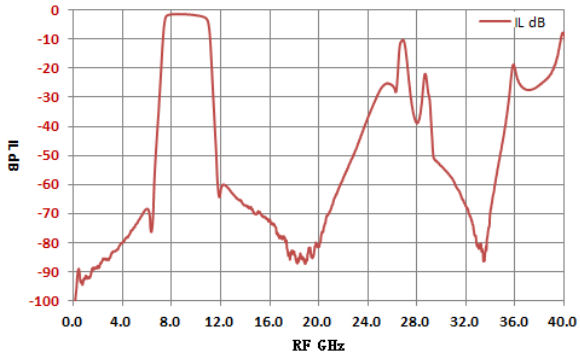
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

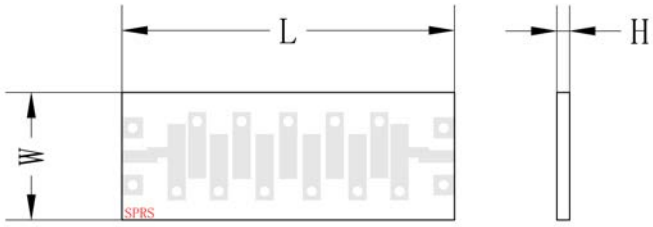
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.7	GHz
工作带宽	7.7-11.7	GHz
中心损耗	2.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-5.4GHz	dBc
带外抑制	40@15.0-20.0GHz	dBc

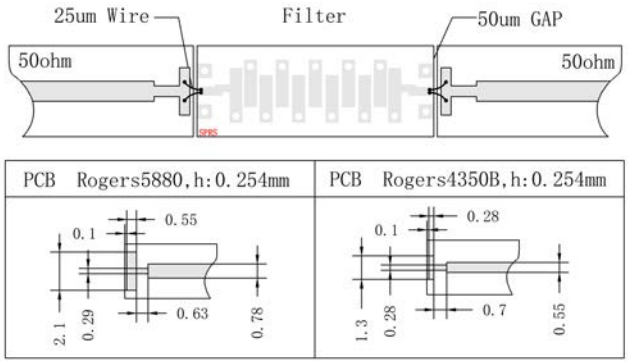
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：3.8，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



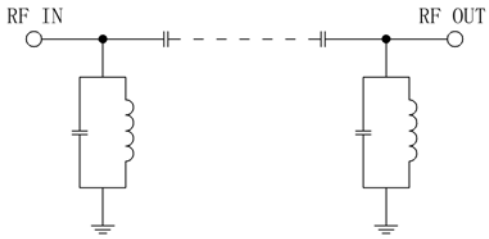
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.87mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

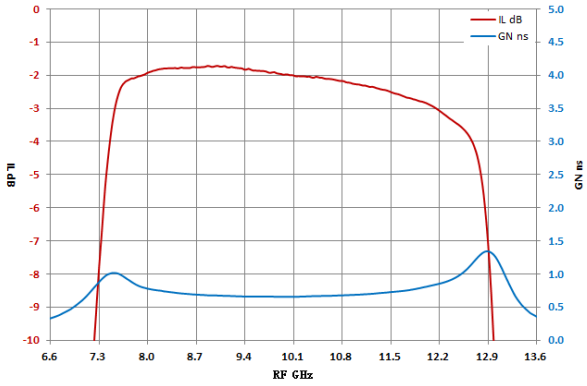
参考实物图

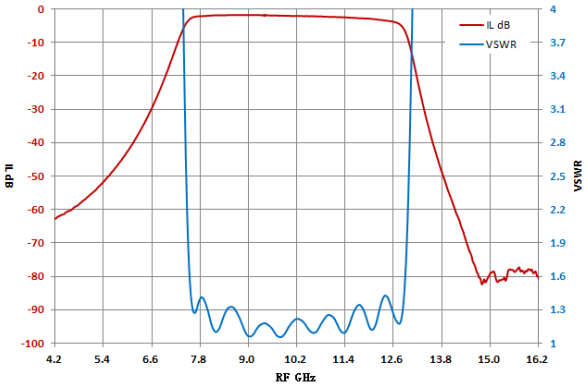


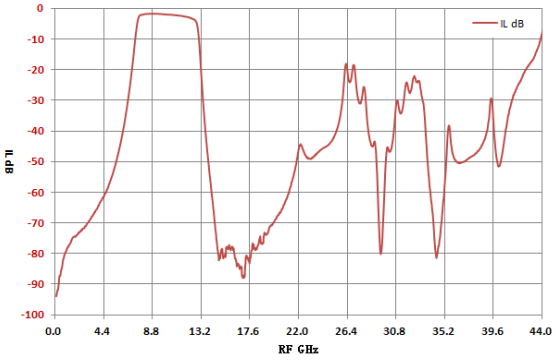
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

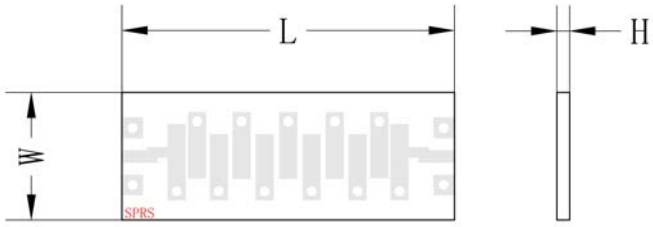
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.8	GHz
工作带宽	7.7-11.9	GHz
中心损耗	2.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-6.0GHz	dBc
带外抑制	40@13.5-19.0GHz	dBc

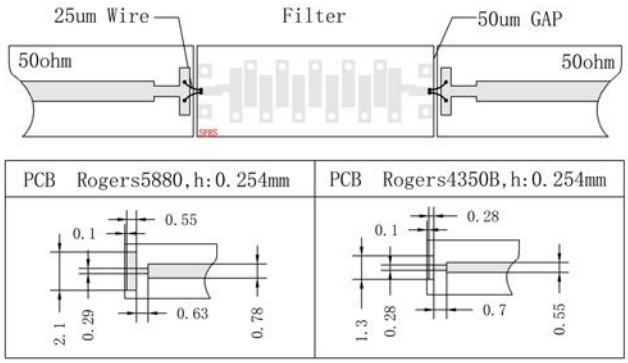
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



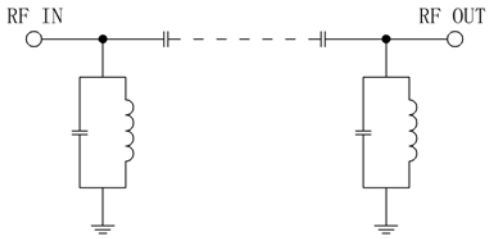
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

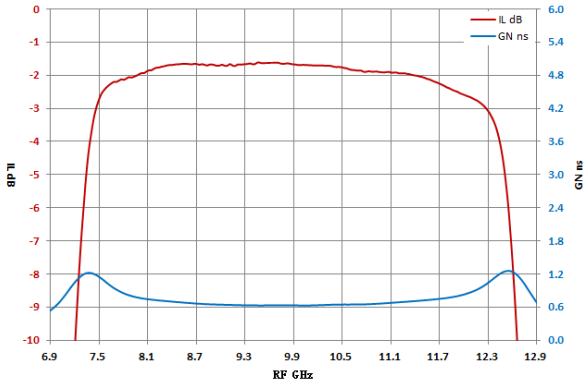
参考实物图

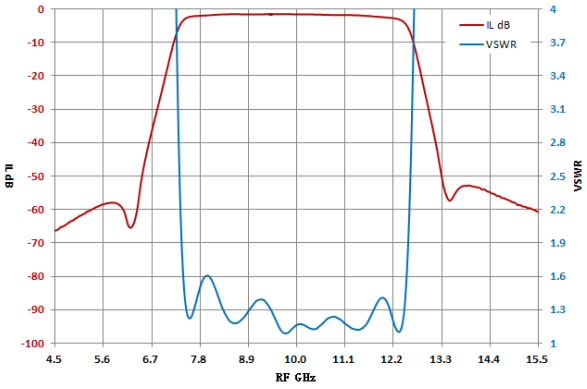


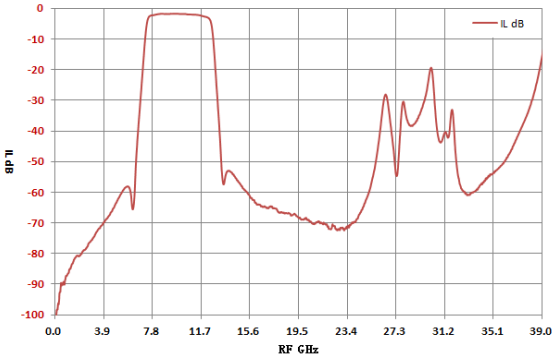
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



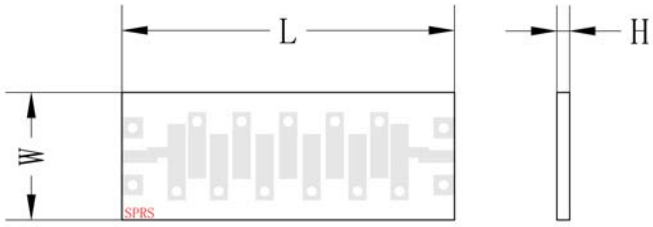
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.4	GHz
工作带宽	7.8-11.0	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-6.3GHz	dBc
带外抑制	40@13.0-24.0GHz	dBc

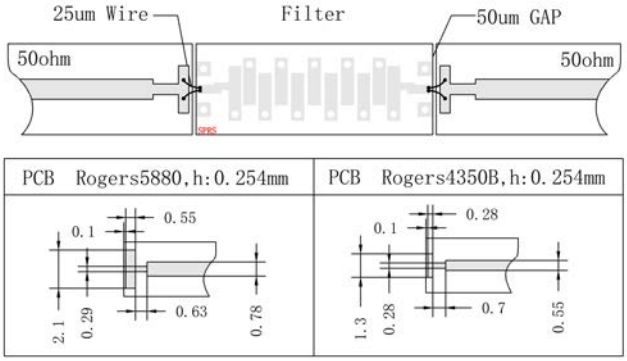
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.5，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



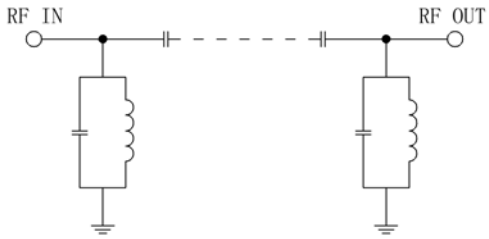
推荐装配图



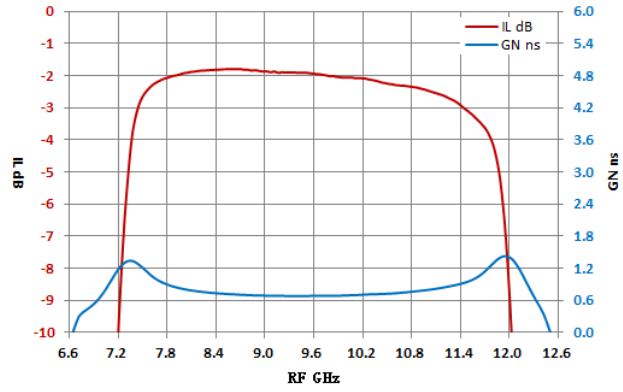
注意事项

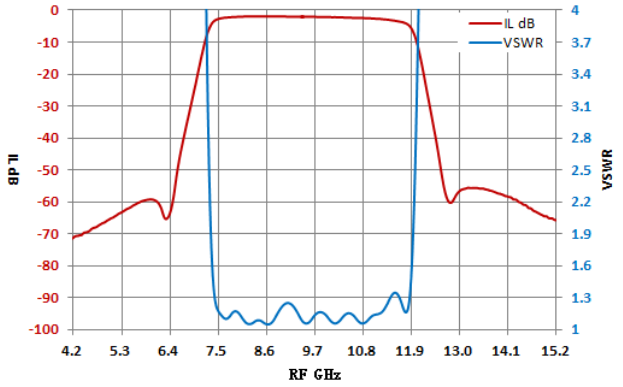
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

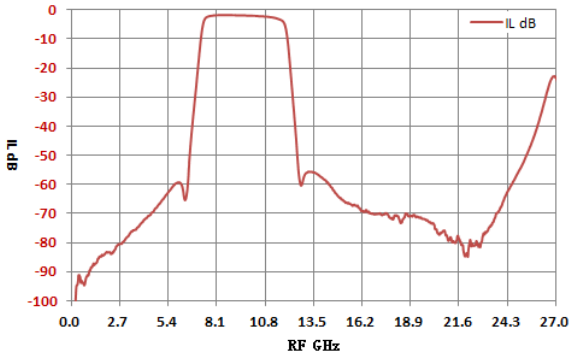
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



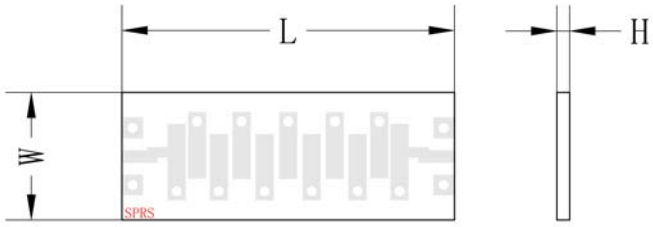
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	10.7	GHz
工作带宽	7.8-13.6	GHz
中心损耗	2.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-4.0GHz	dBc
带外抑制	40@17.4-26.0GHz	dBc

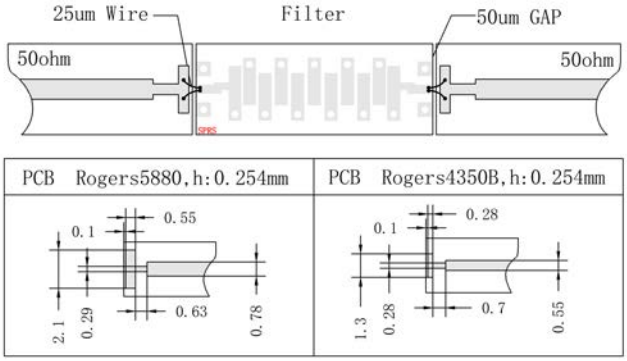
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



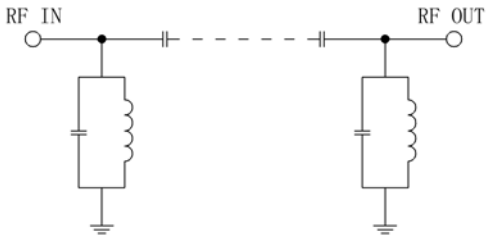
推荐装配图



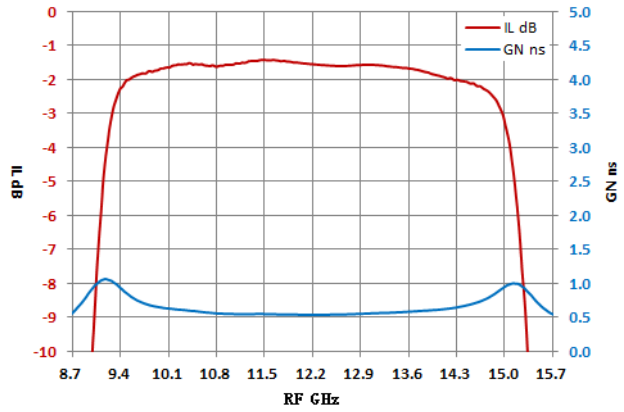
注意事项

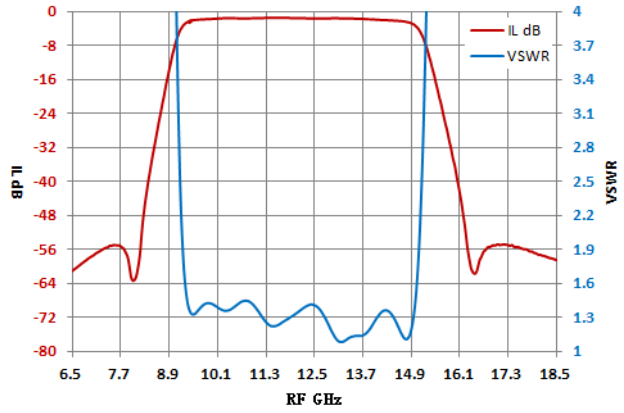
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

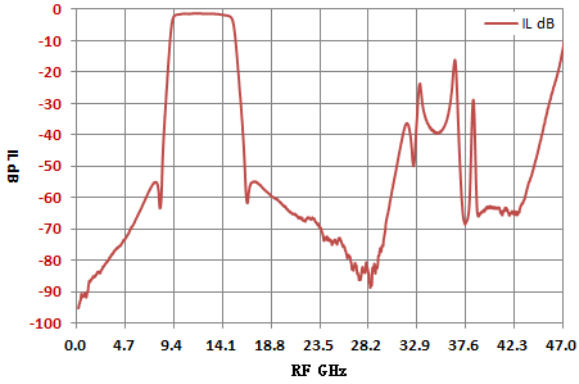
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



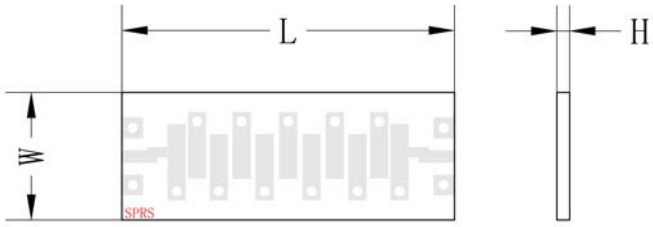
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	8.0	GHz
工作带宽	7.9-8.1	GHz
中心损耗	4.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.7	ns
带外抑制	35@DC-7.2GHz	dBc
带外抑制	40@9.2-14.0GHz	dBc

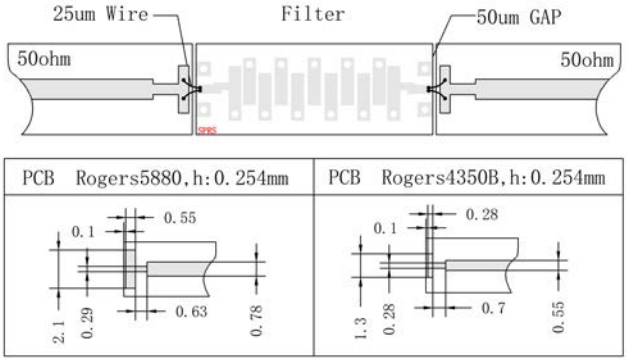
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：5.0，h：0.26

外形图：端口居中



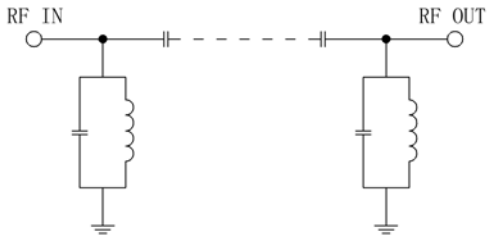
推荐装配图



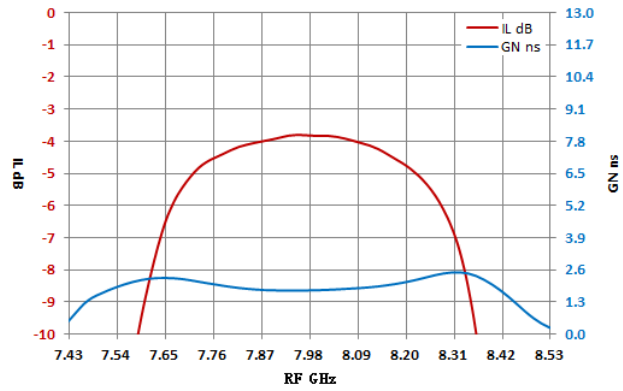
注意事项

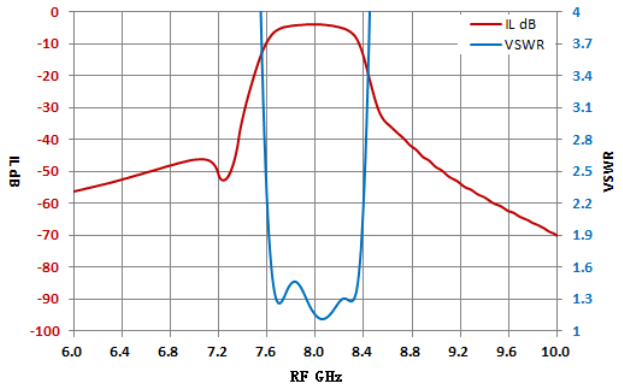
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

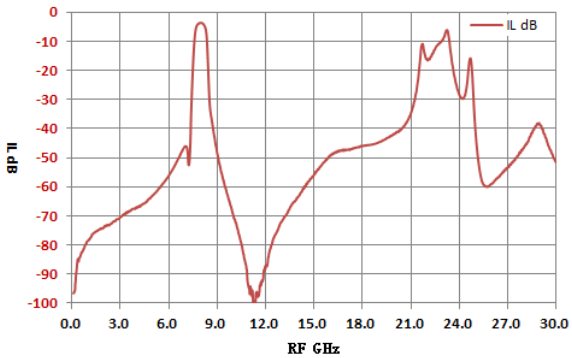
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



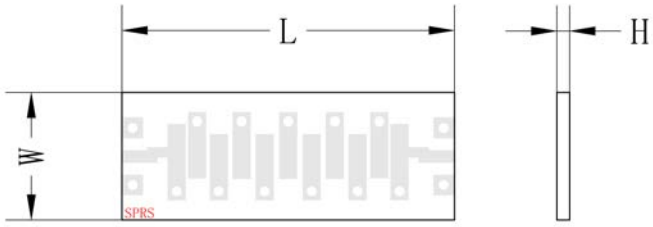
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	8.0	GHz
工作带宽	7.9-8.1	GHz
中心损耗	5.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-7.1GHz	dBc
带外抑制	40@8.7-21.0GHz	dBc

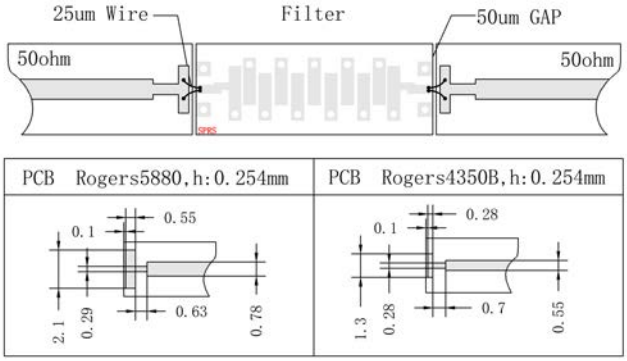
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.0，W：4.5，h：0.26

外形图：端口居中



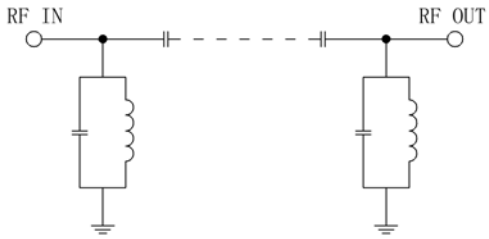
推荐装配图



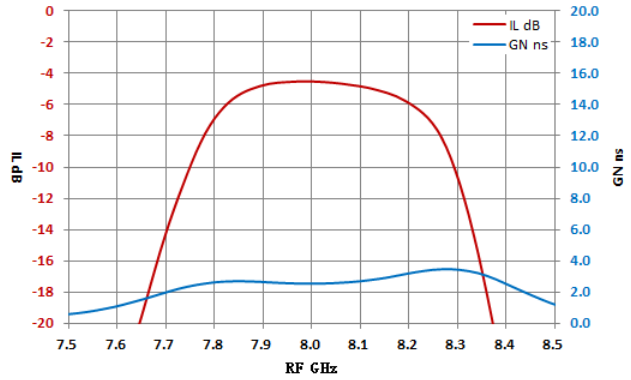
注意事项

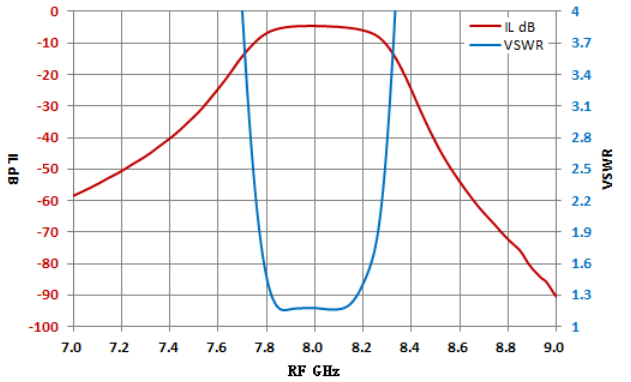
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

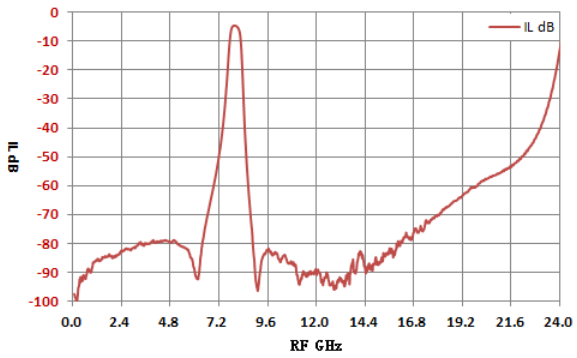
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

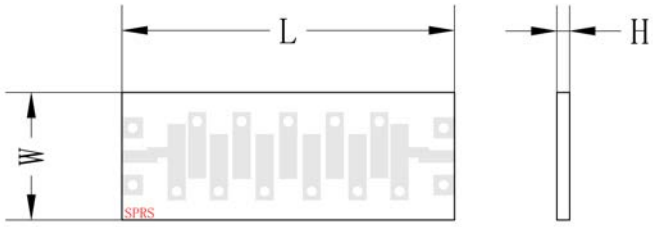
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	8.0	GHz
工作带宽	7.9-8.1	GHz
中心损耗	5.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-7.4GHz	dBc
带外抑制	40@8.7-20.0GHz	dBc

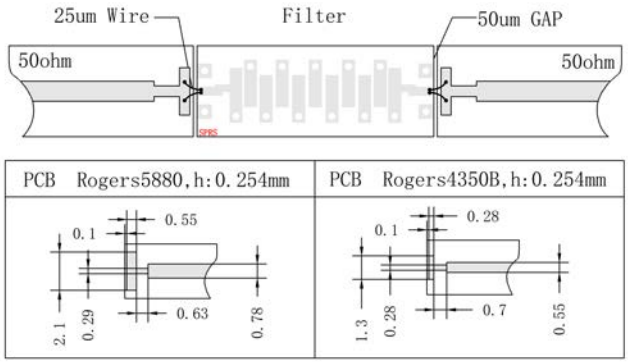
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：4.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



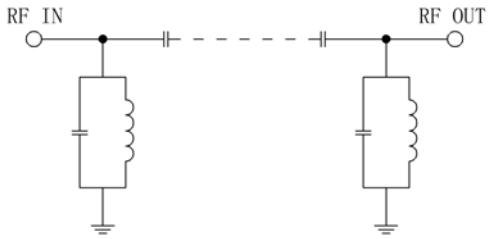
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

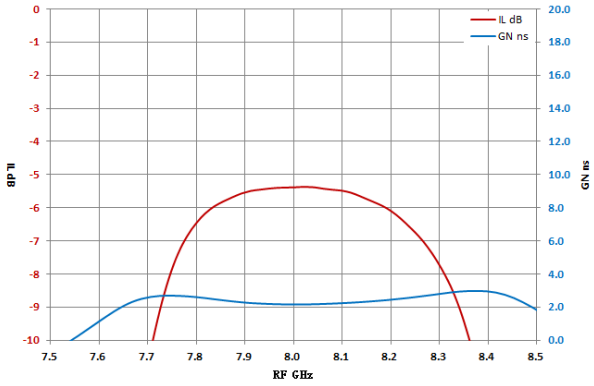
参考实物图

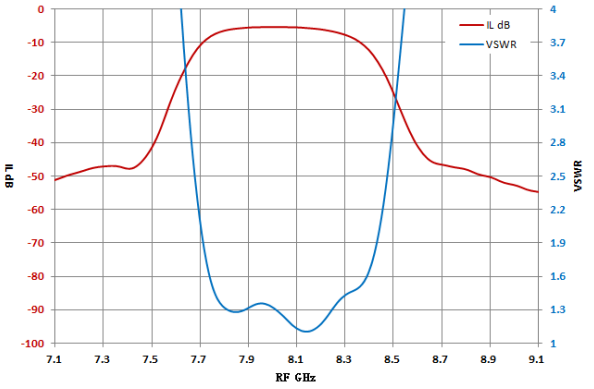


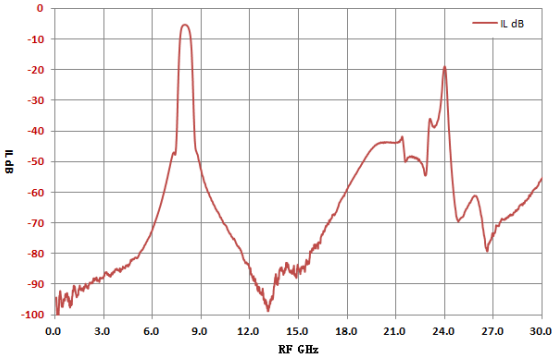
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

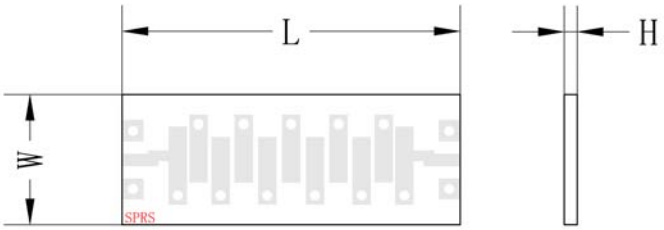
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	8.4	GHz
工作带宽	7.9-8.9	GHz
中心损耗	1.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.6	ns
带外抑制	40@DC-6.9GHz	dBc
带外抑制	40@9.8-20.0GHz	dBc

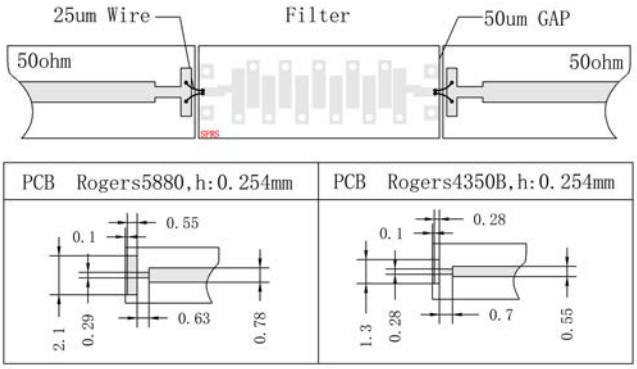
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：9.0，W：3.5，h：0.39

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.61mm,端口可互换;

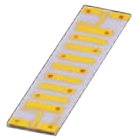
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

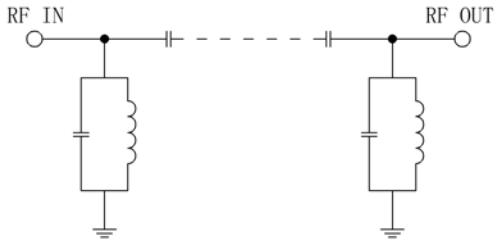
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

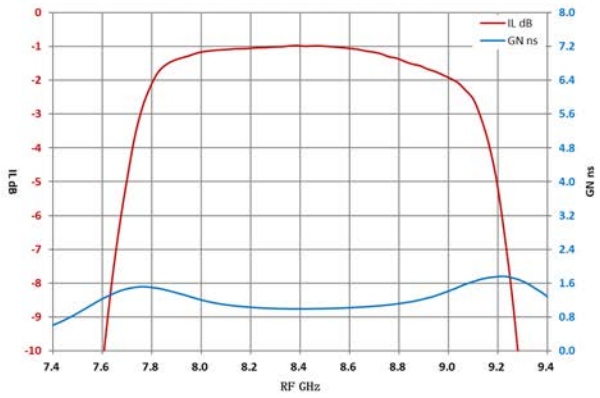
参考图

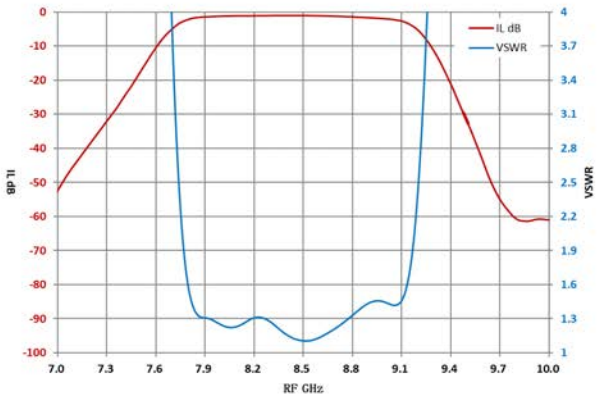


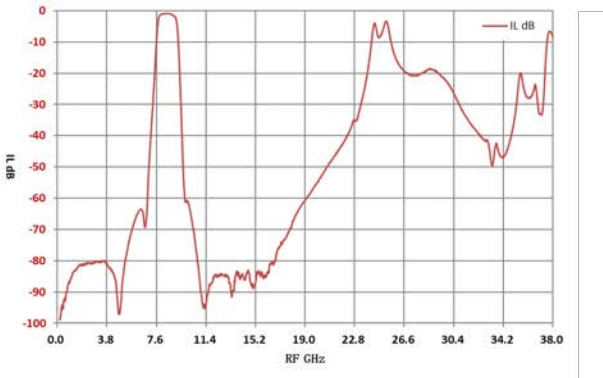
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



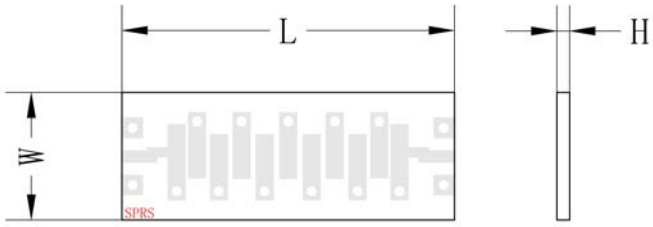
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	8.5	GHz
工作带宽	7.9-9.1	GHz
中心损耗	2.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-6.9GHz	dBc
带外抑制	40@10.6-18.0GHz	dBc

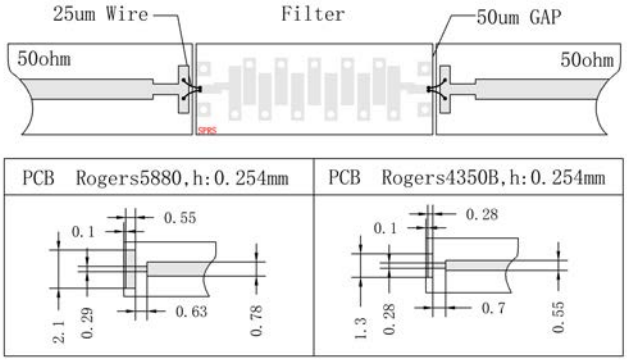
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：4.5，h：0.26

外形图：端口居中



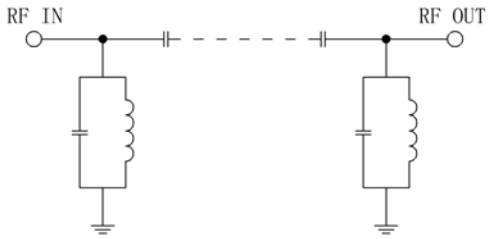
推荐装配图



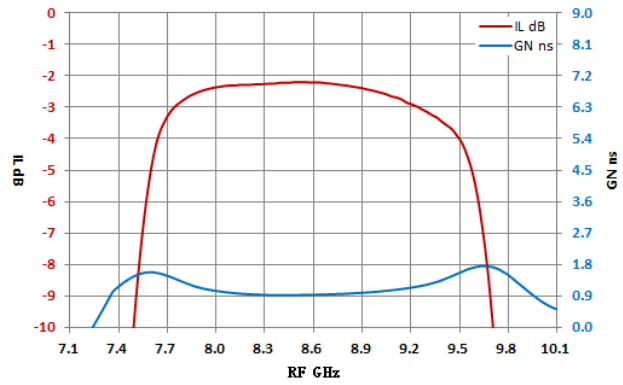
注意事项

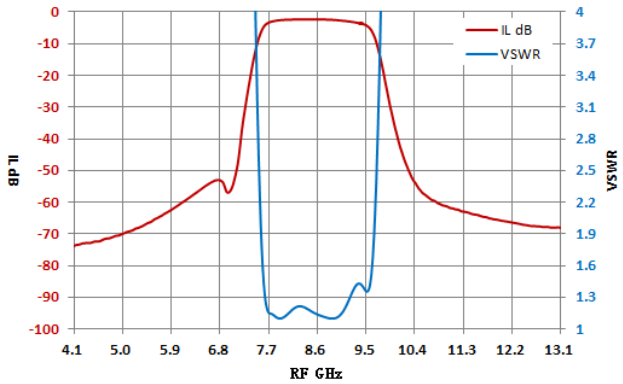
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

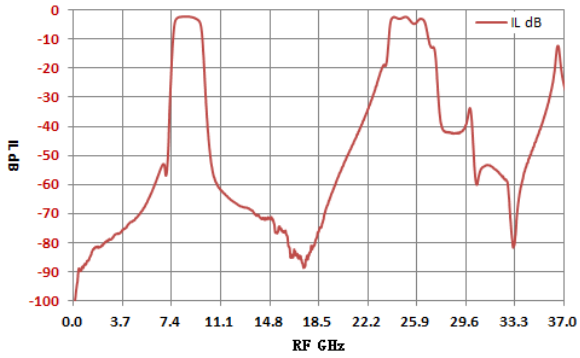
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



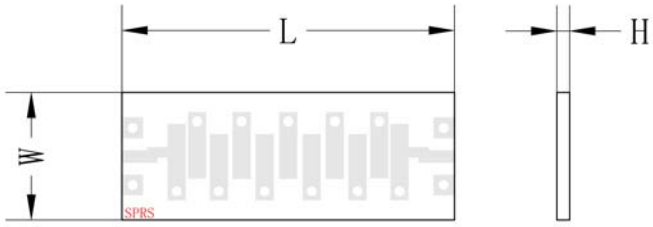
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	10.4	GHz
工作带宽	7.9-12.8	GHz
中心损耗	1.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-5.3GHz	dBc
带外抑制	40@15.1-26.0GHz	dBc

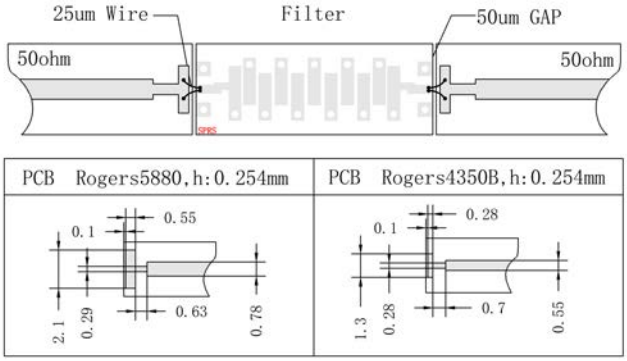
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



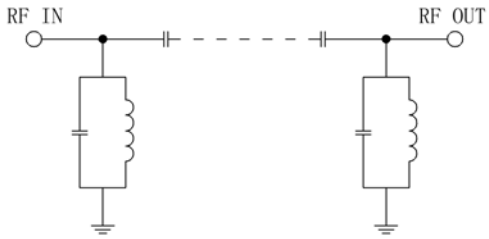
推荐装配图



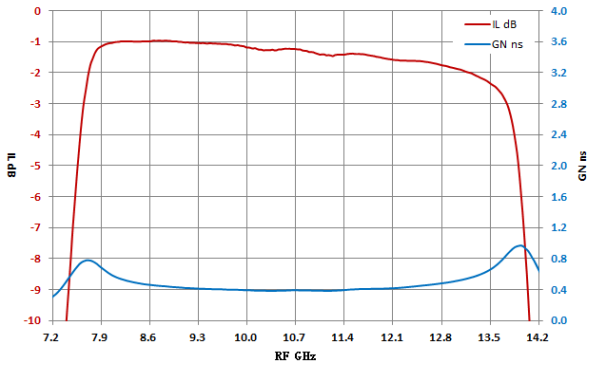
注意事项

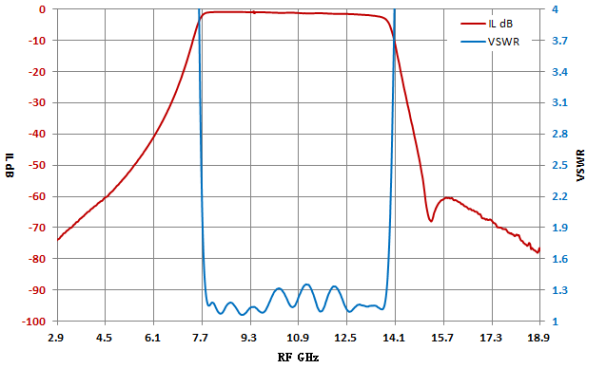
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

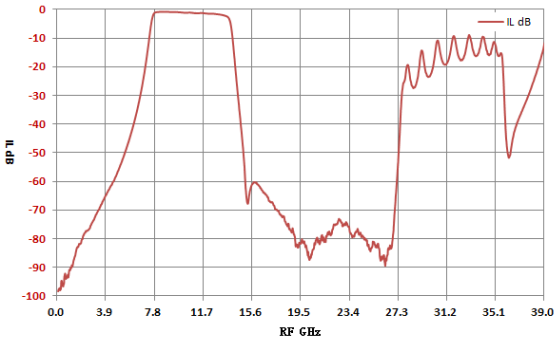
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



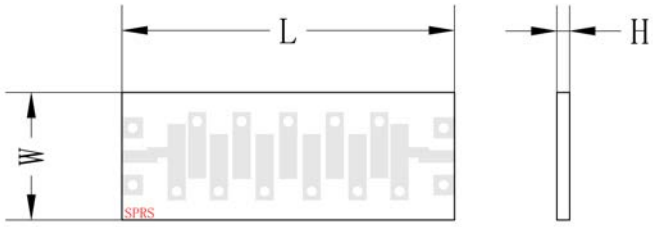
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	10.7	GHz
工作带宽	7.9-13.4	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-6.0GHz	dBc
带外抑制	40@16.2-25.0GHz	dBc

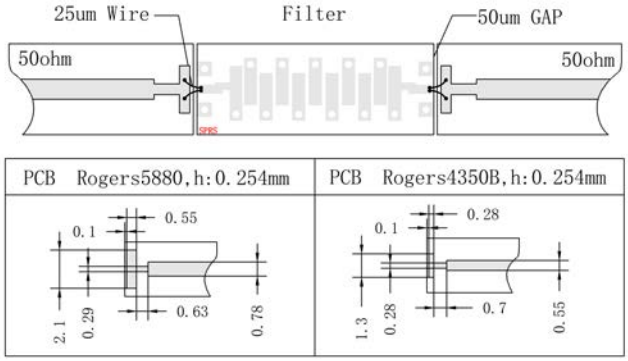
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



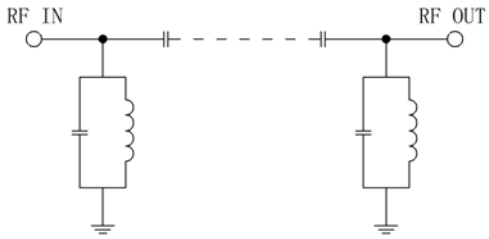
推荐装配图



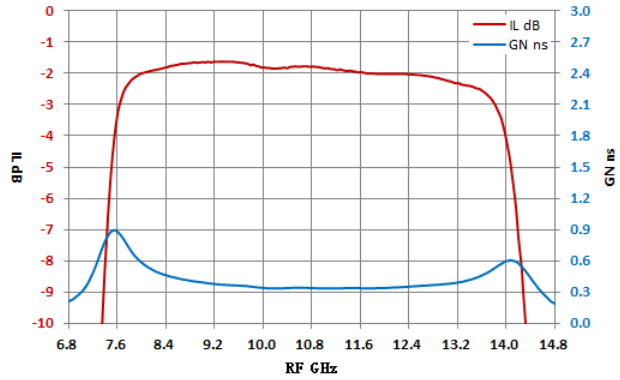
注意事项

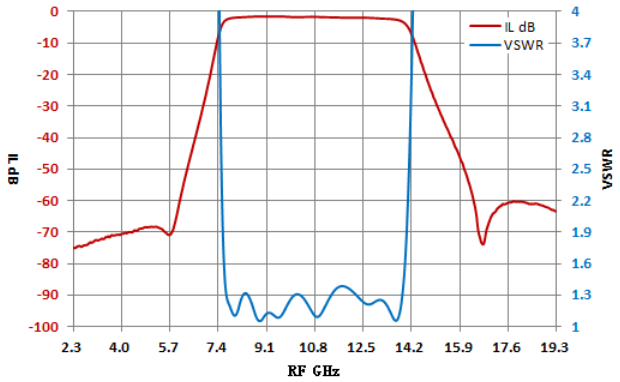
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

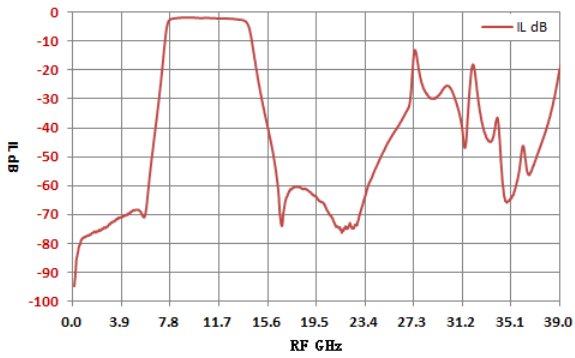
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



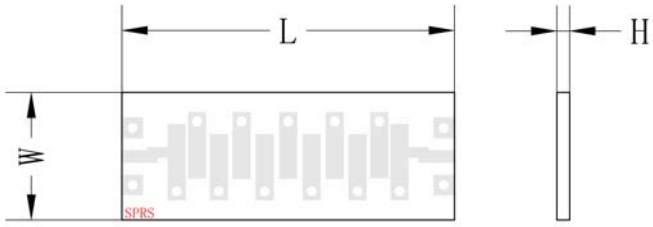
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	8.25	GHz
工作带宽	8.0-8.5	GHz
中心损耗	2.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-7.1GHz	dBc
带外抑制	40@10.4-15.0GHz	dBc

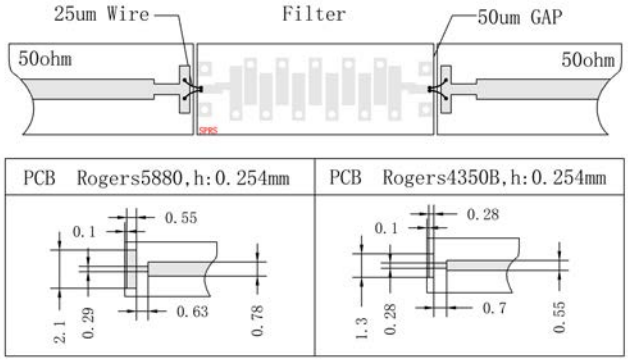
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：4.5，h：0.26

外形图：端口居中



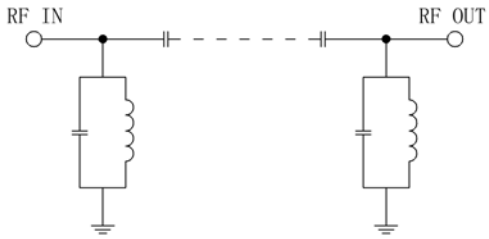
推荐装配图



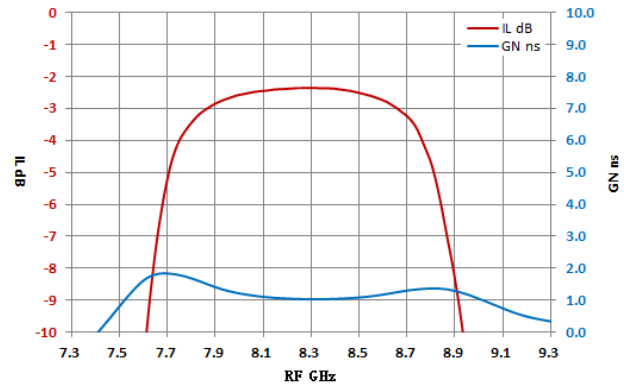
注意事项

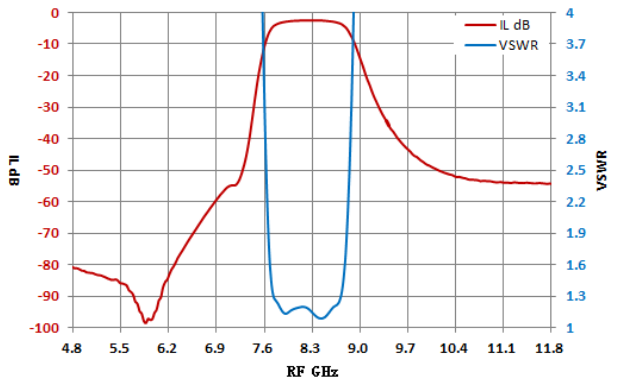
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

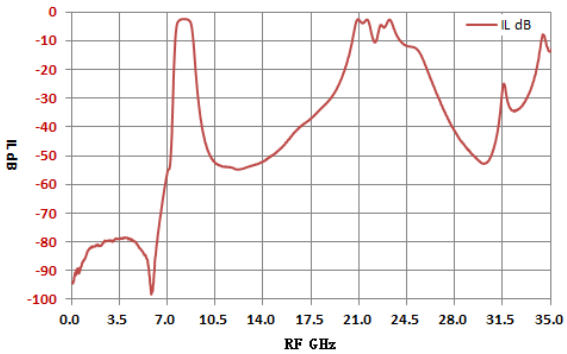
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



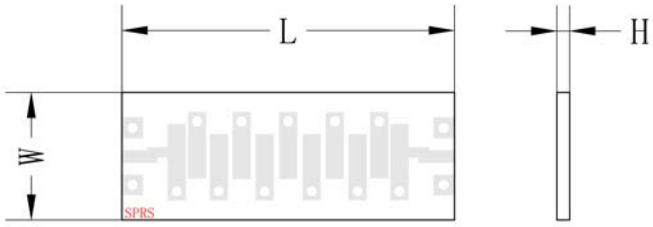
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	8.8	GHz
工作带宽	8.0-9.6	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.6	ns
带外抑制	35@DC-7.0GHz	dBc
带外抑制	40@10.9-18.0GHz	dBc

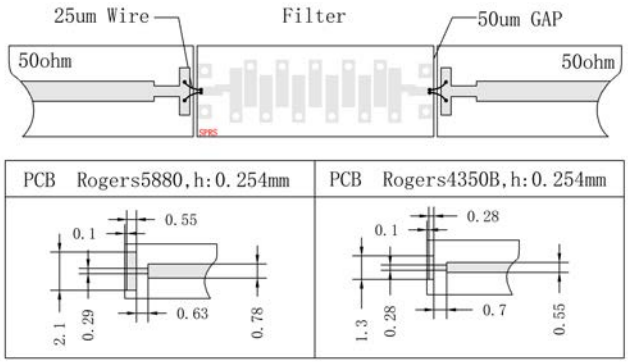
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：4.5，h：0.26

外形图：端口居中



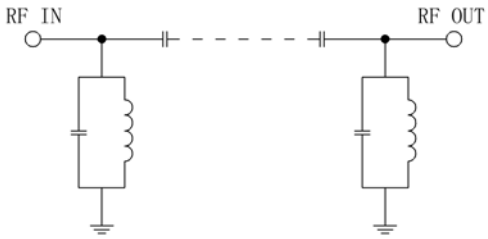
推荐装配图



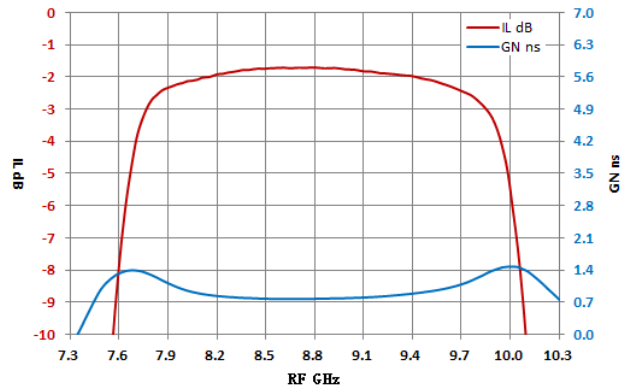
注意事项

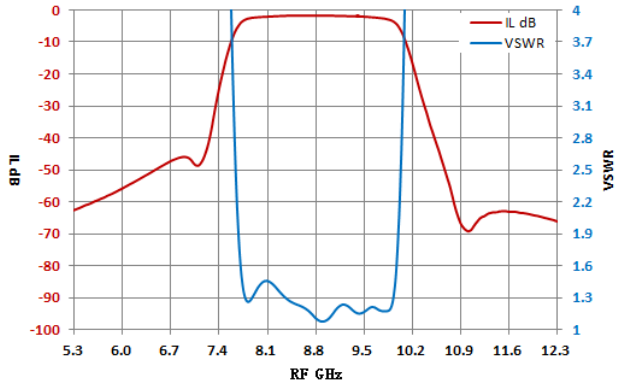
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

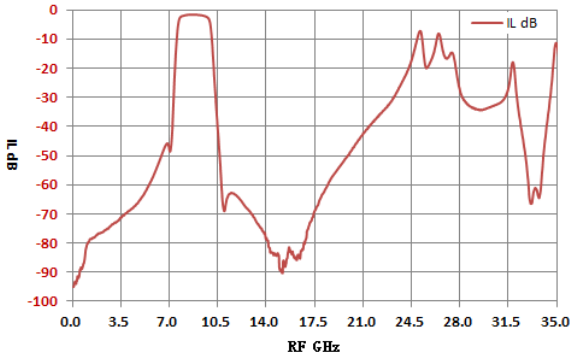
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



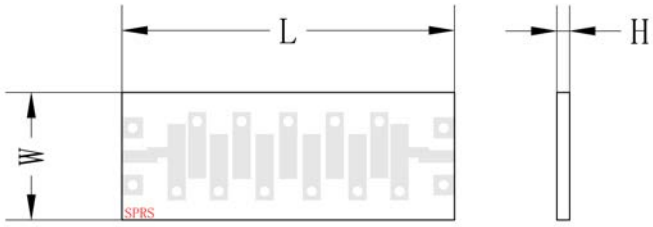
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.5	GHz
工作带宽	8.0-11.0	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-6.7GHz	dBc
带外抑制	40@12.5-23.0GHz	dBc

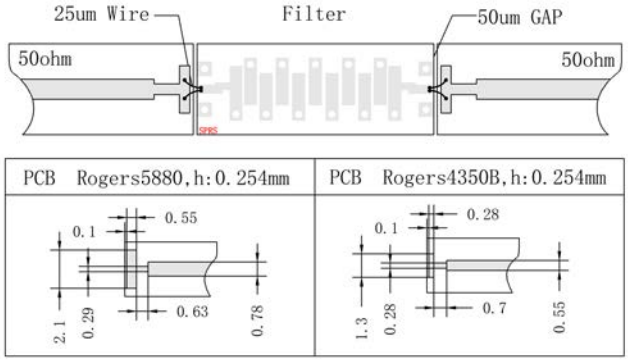
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



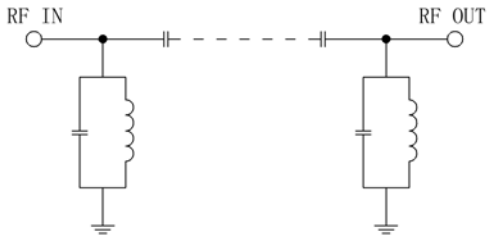
推荐装配图



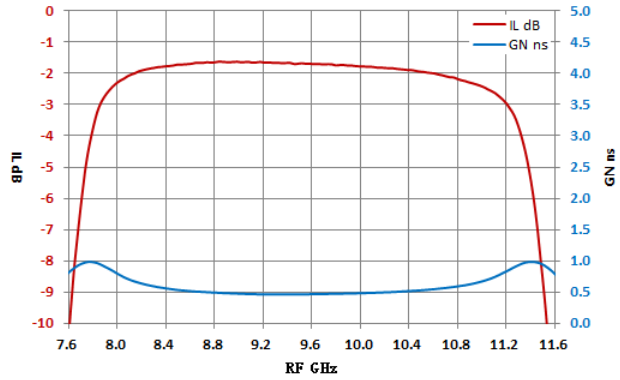
注意事项

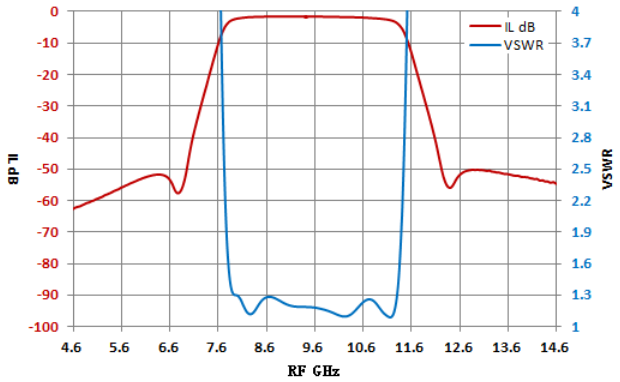
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

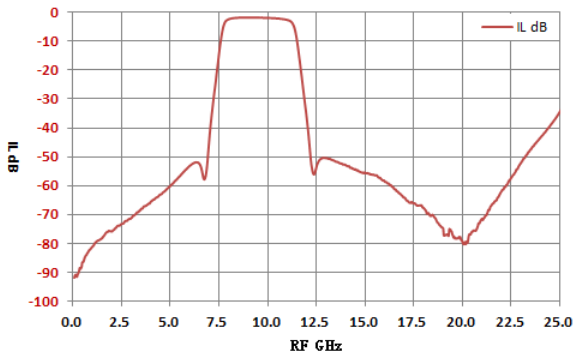
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



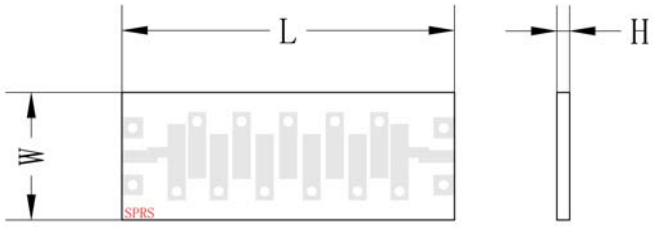
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.9	GHz
工作带宽	8.0-11.8	GHz
中心损耗	2.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-6.2GHz	dBc
带外抑制	40@14.0-23.0GHz	dBc

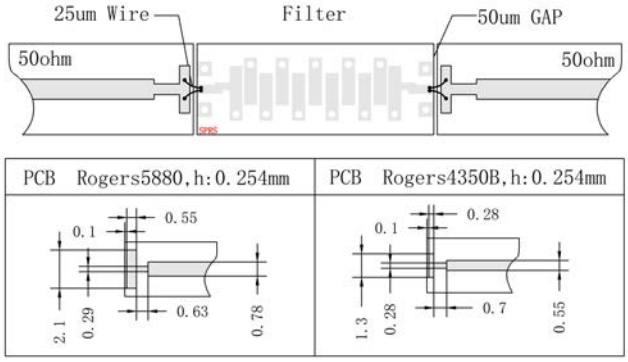
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



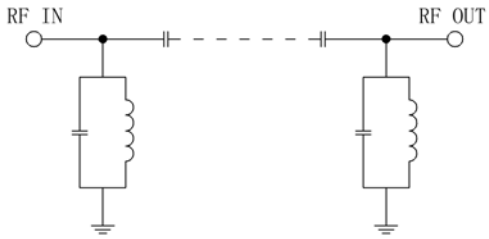
推荐装配图



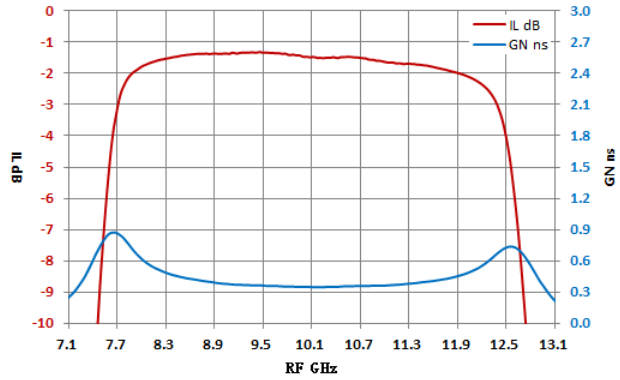
注意事项

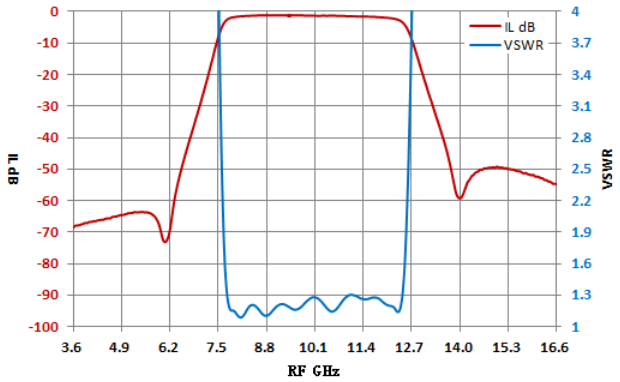
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

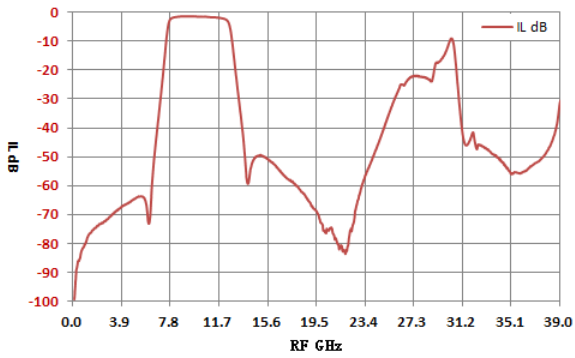
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



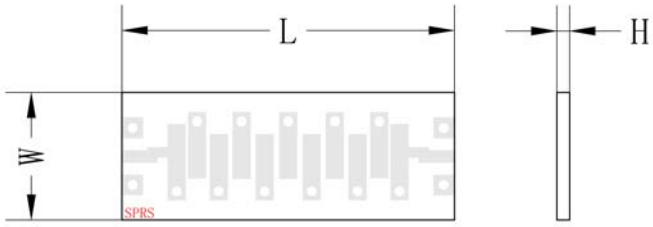
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	10.1	GHz
工作带宽	8.0-12.2	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-6.5GHz	dBc
带外抑制	35@13.8-22.0GHz	dBc

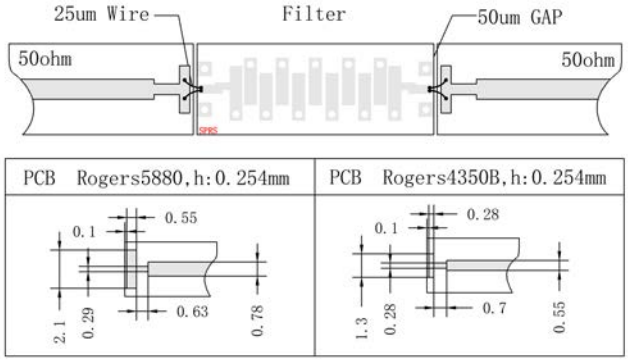
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：4.0，h：0.39

外形图：端口居中



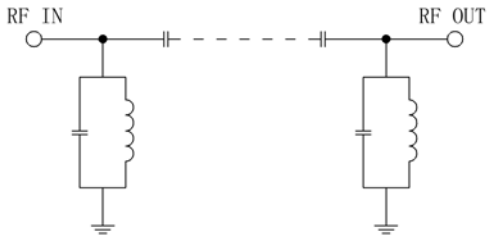
推荐装配图



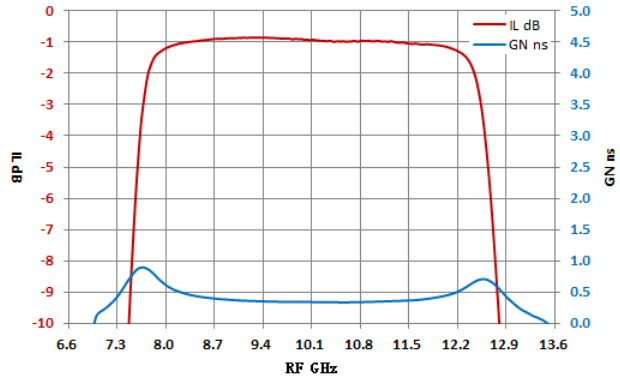
注意事项

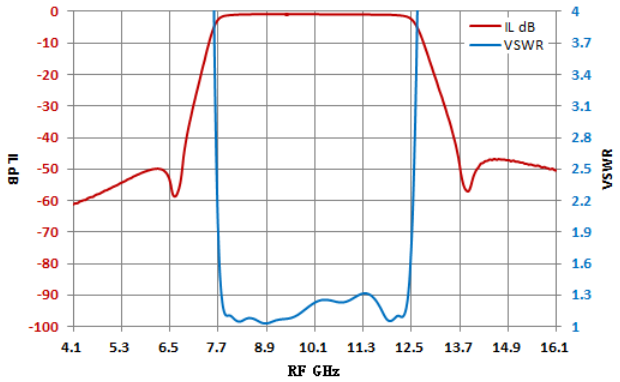
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

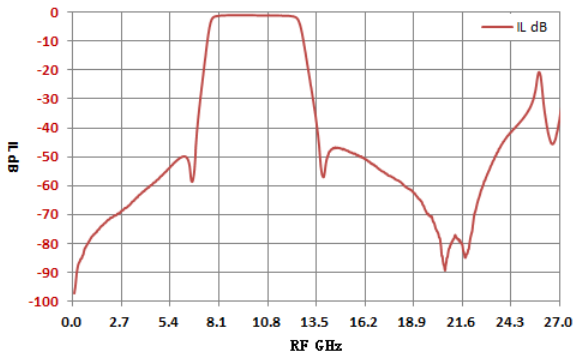
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



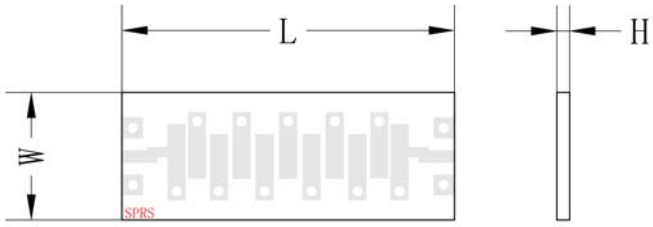
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	11.0	GHz
工作带宽	8.0-14.0	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-3.0GHz	dBc
带外抑制	30@16.2-24.0GHz	dBc

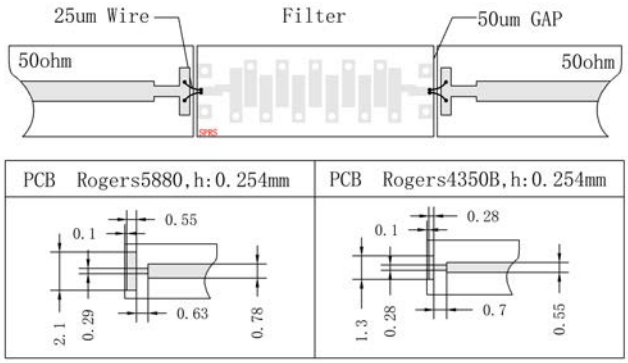
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



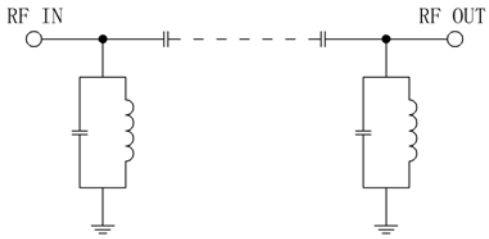
推荐装配图



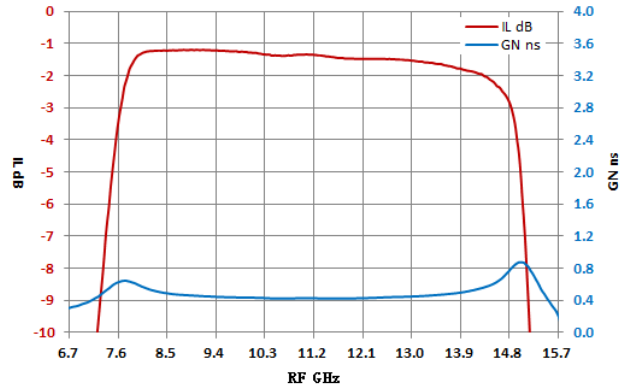
注意事项

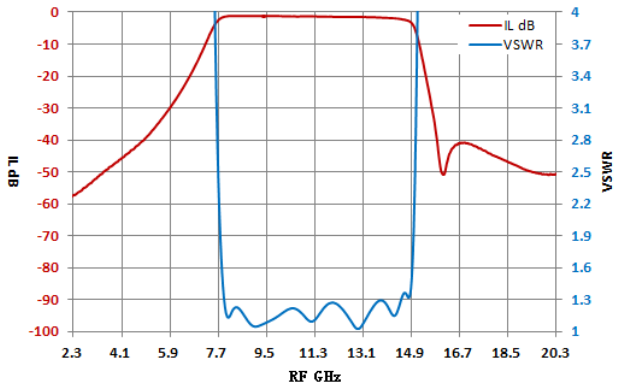
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

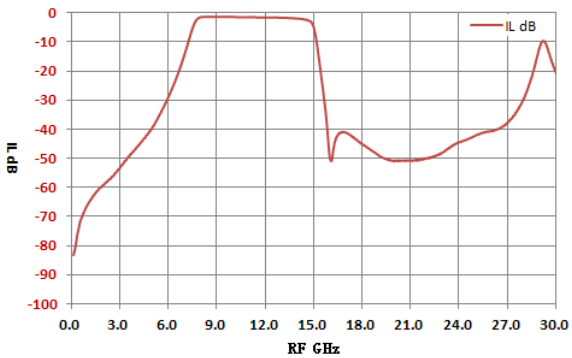
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

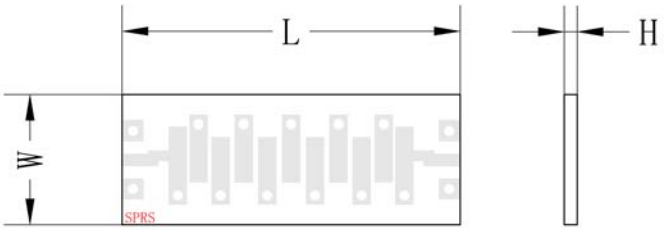
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	15.2	GHz
工作带宽	8.0-22.4	GHz
中心损耗	1.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.8:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-6.0GHz	dBc
带外抑制	40@26.5-31.5GHz	dBc

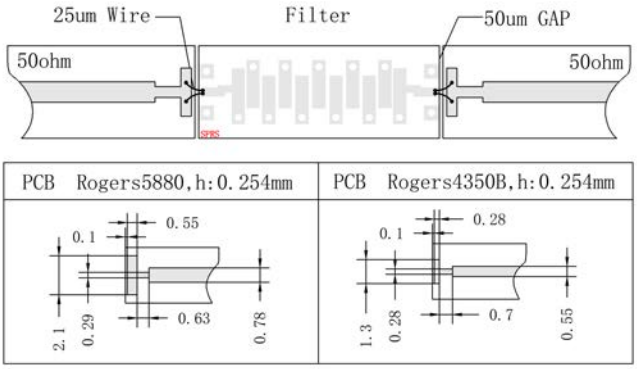
其它要求：设计保证

承受功率	0.5W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：6.5，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

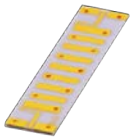
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

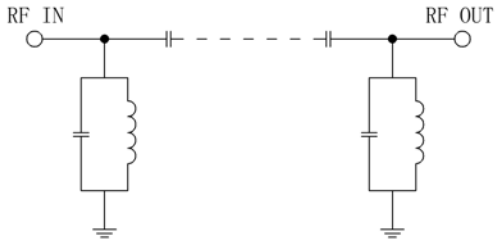
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

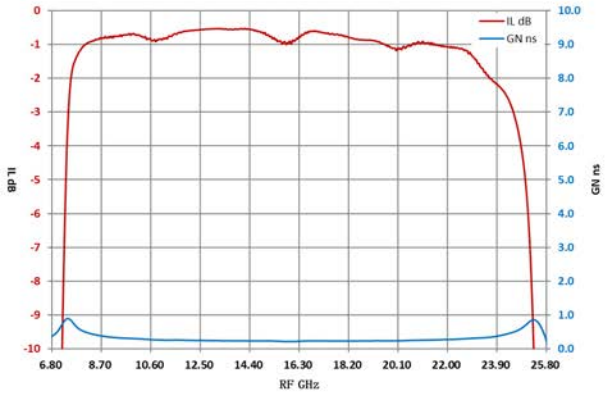
参考图

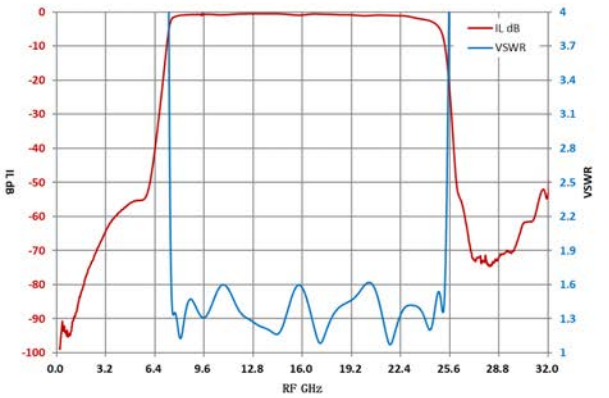


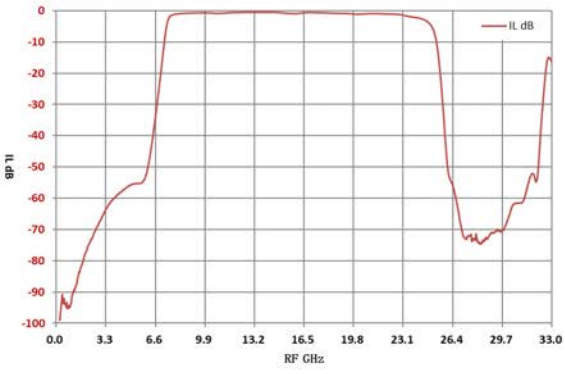
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



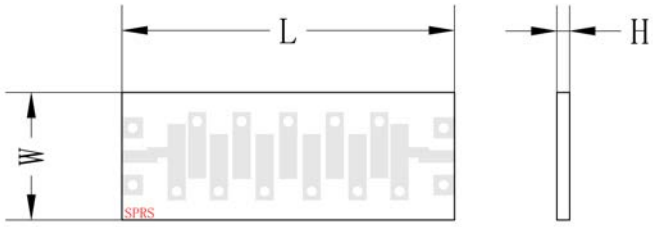
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	10.2	GHz
工作带宽	8.1-12.3	GHz
中心损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-6.0GHz	dBc
带外抑制	40@14.2-21.0GHz	dBc

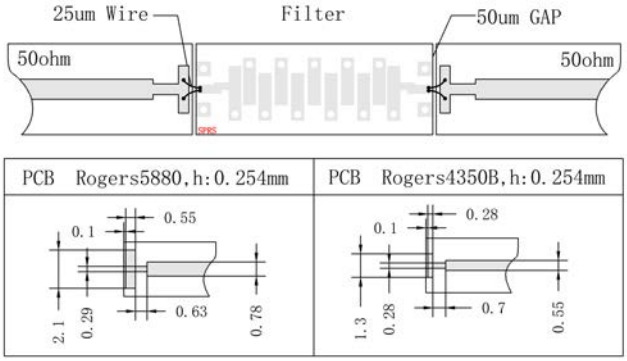
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



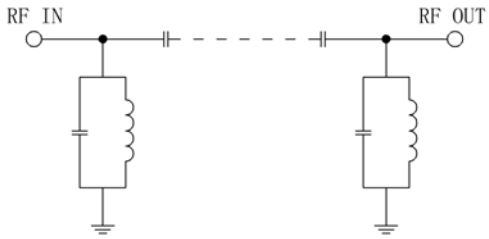
推荐装配图



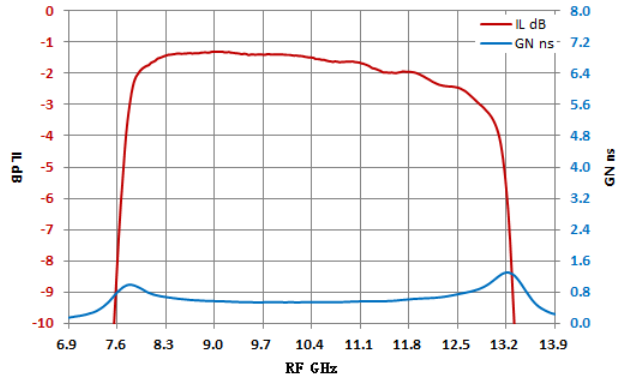
注意事项

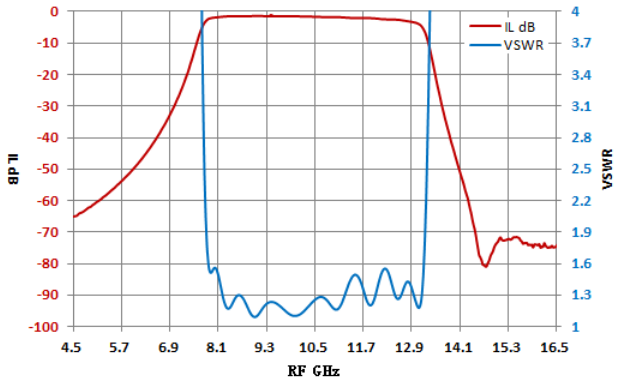
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

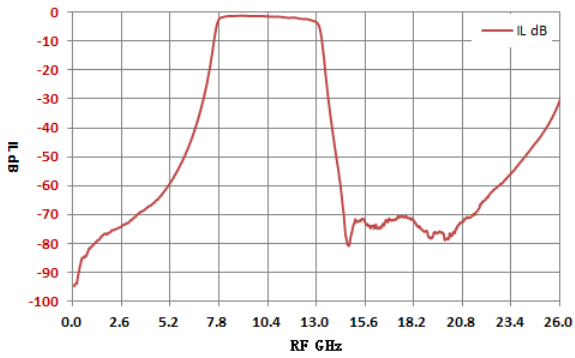
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



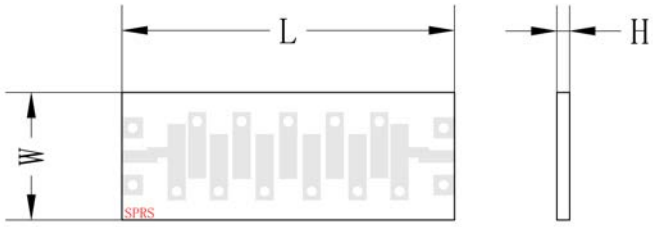
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.5	GHz
工作带宽	8.2-10.8	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-6.9GHz	dBc
带外抑制	40@12.4-22.0GHz	dBc

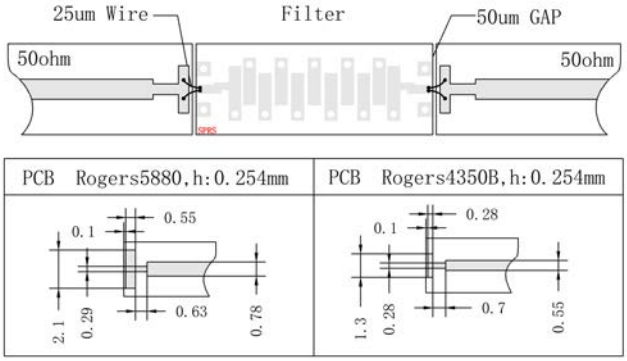
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



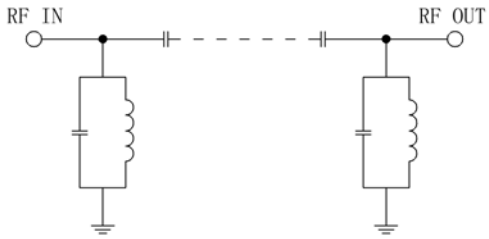
推荐装配图



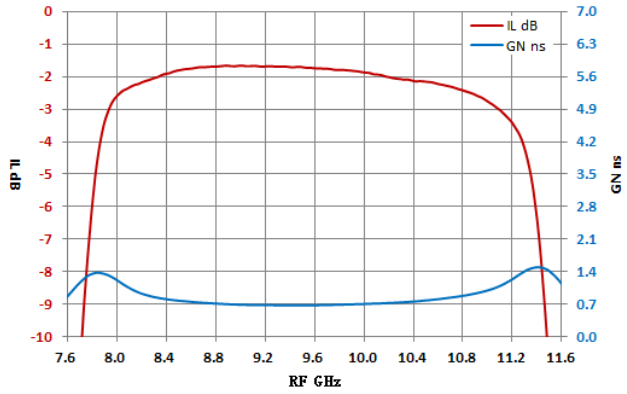
注意事项

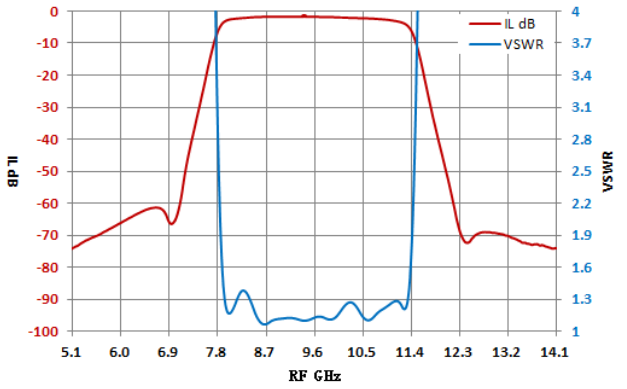
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

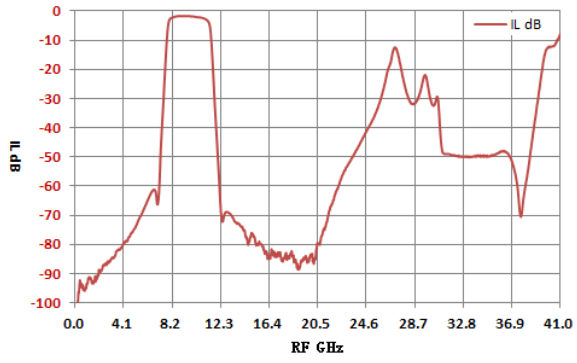
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



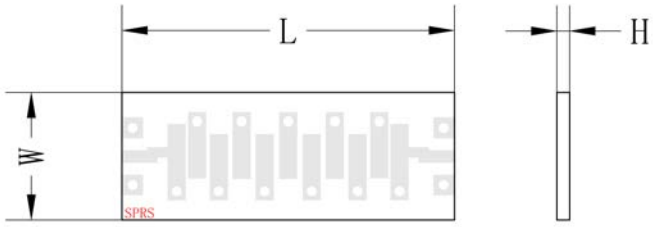
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	10.4	GHz
工作带宽	8.2-12.5	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-6.5GHz	dBc
带外抑制	40@14.4-23.0GHz	dBc

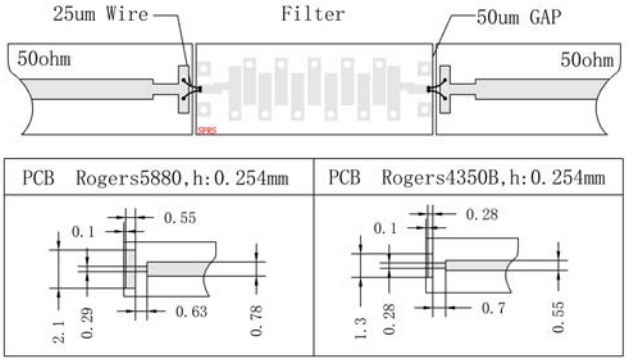
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：4.0，h：0.39

外形图：端口居中



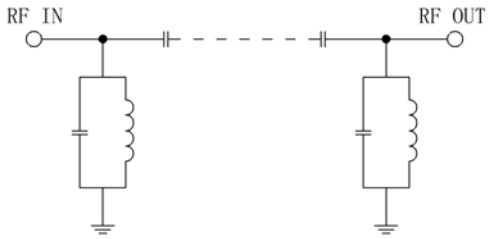
推荐装配图



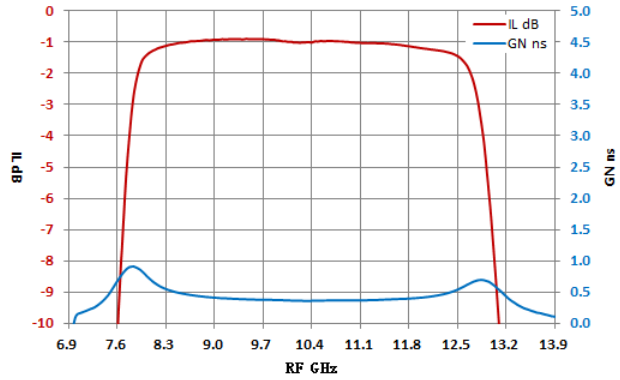
注意事项

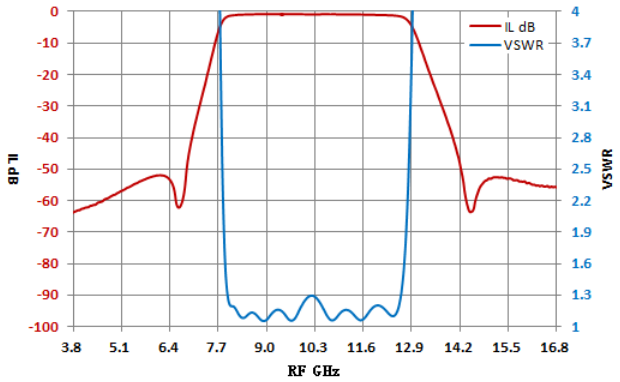
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

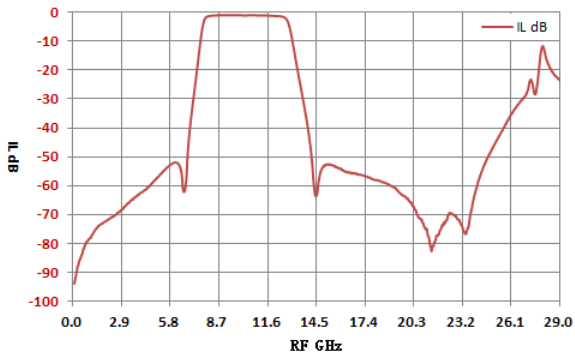
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



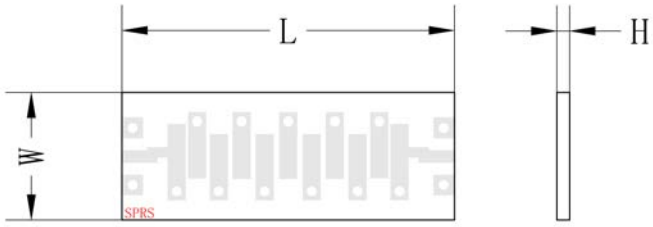
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	8.6	GHz
工作带宽	8.3-8.9	GHz
中心损耗	3.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-7.0GHz	dBc
带外抑制	40@10.2-19.0GHz	dBc

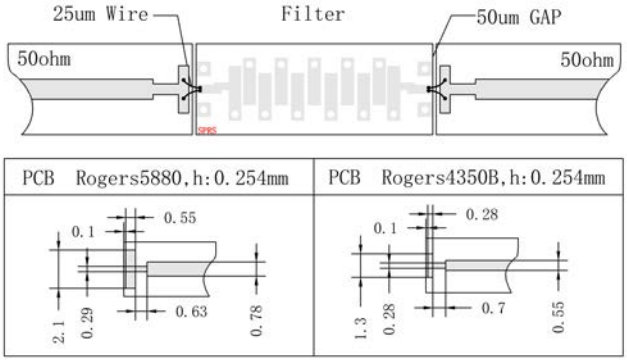
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：4.5，h：0.26

外形图：端口居中



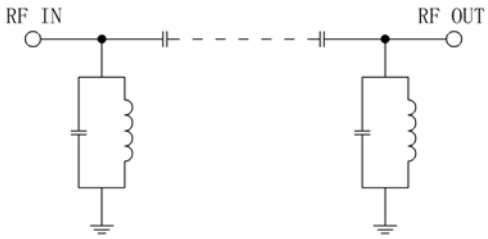
推荐装配图



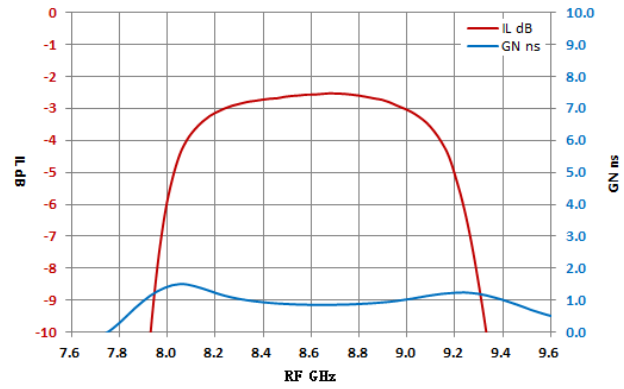
注意事项

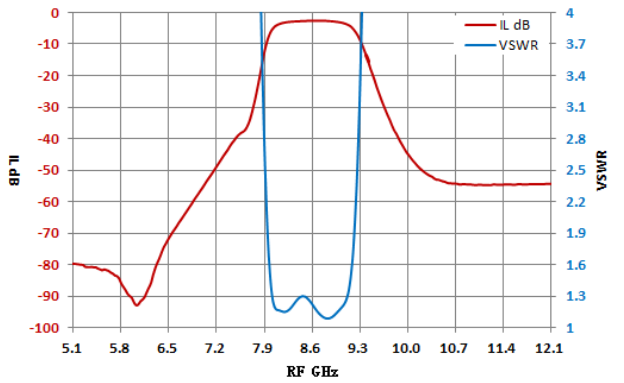
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

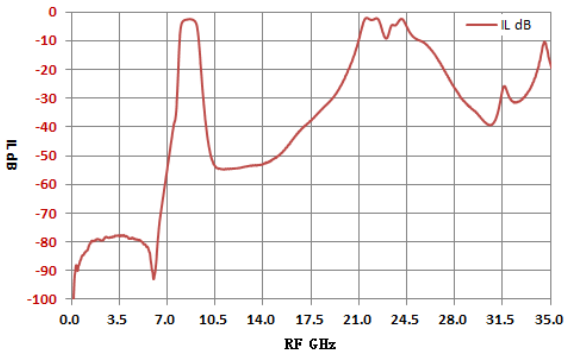
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



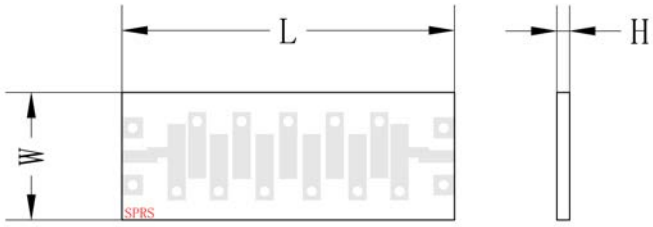
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	8.9	GHz
工作带宽	8.3-9.4	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-6.8GHz	dBc
带外抑制	40@10.9-19.0GHz	dBc

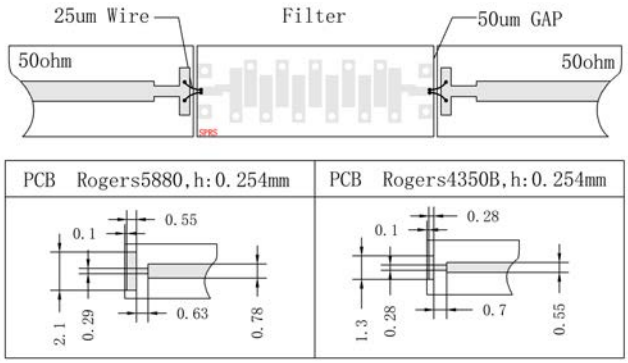
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



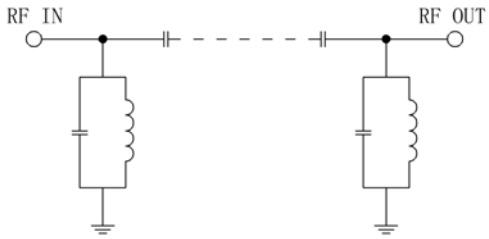
推荐装配图



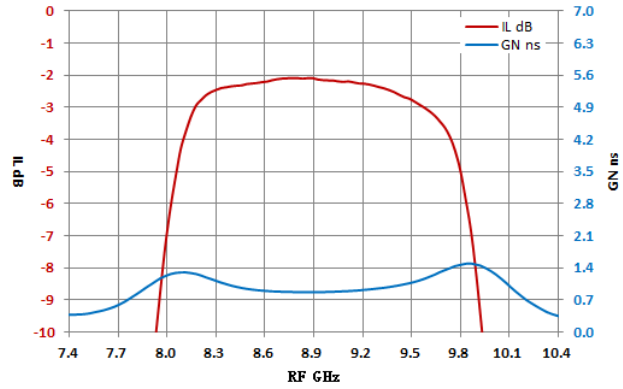
注意事项

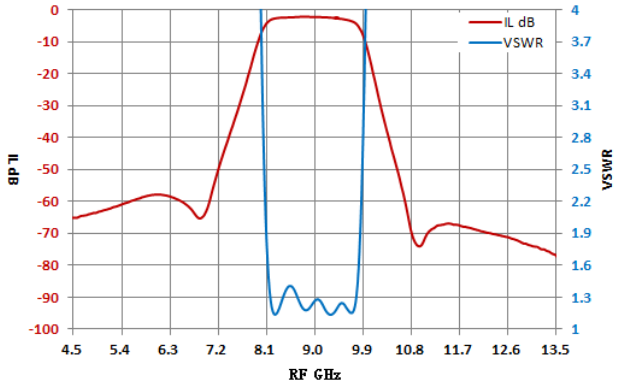
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

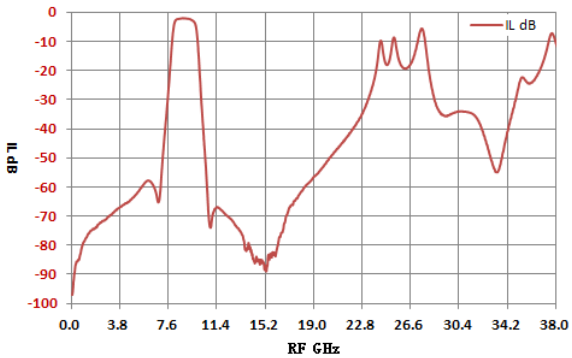
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



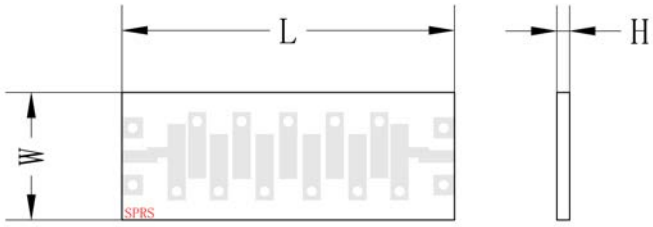
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	8.9	GHz
工作带宽	8.3-9.5	GHz
中心损耗	2.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	1.0	ns
带外抑制	30@DC-7.5GHz	dBc
带外抑制	35@10.5-20.0GHz	dBc

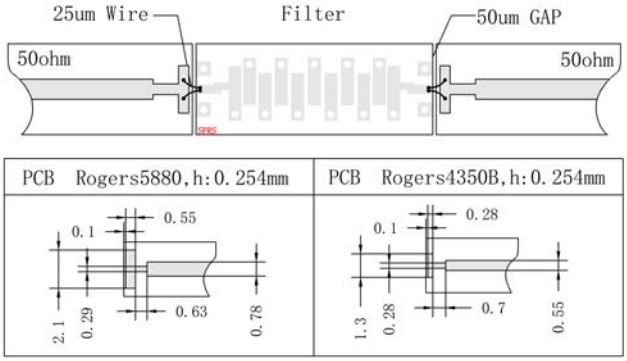
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



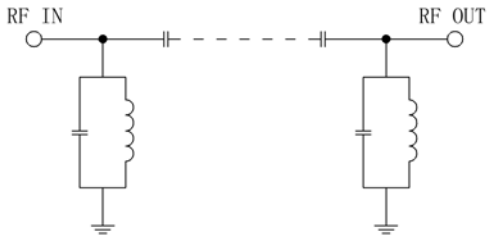
推荐装配图



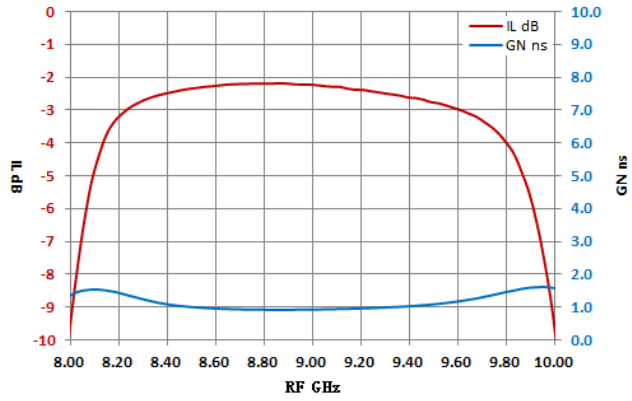
注意事项

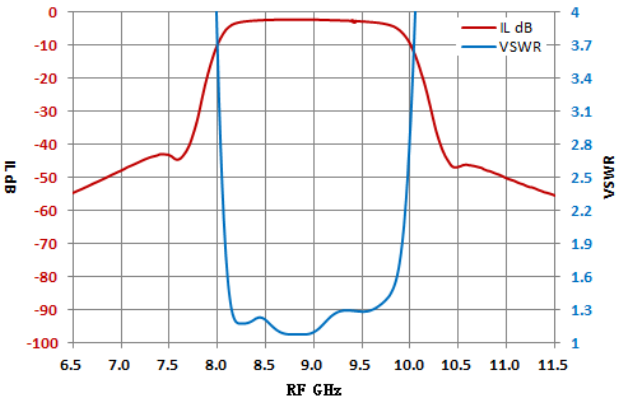
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

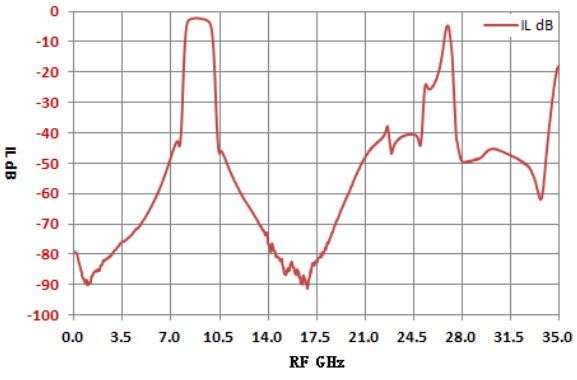
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



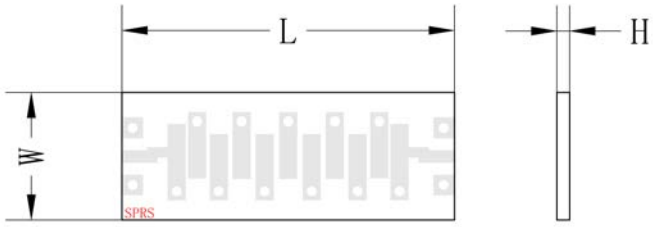
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.5	GHz
工作带宽	8.3-10.7	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-7.3GHz	dBc
带外抑制	40@12.1-21.0GHz	dBc

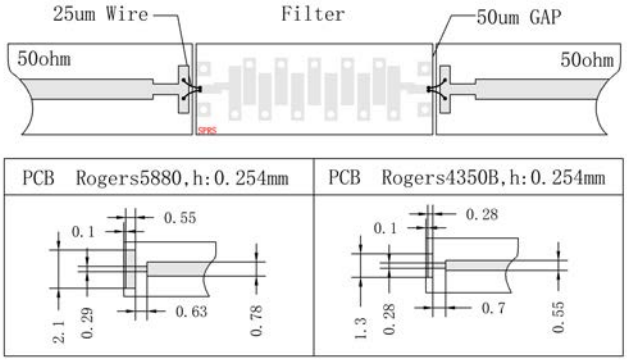
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.5，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



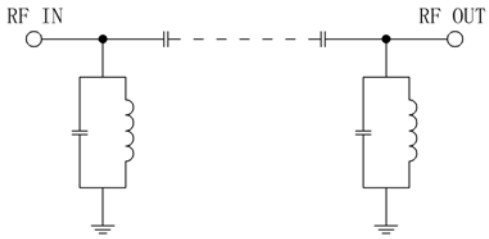
推荐装配图



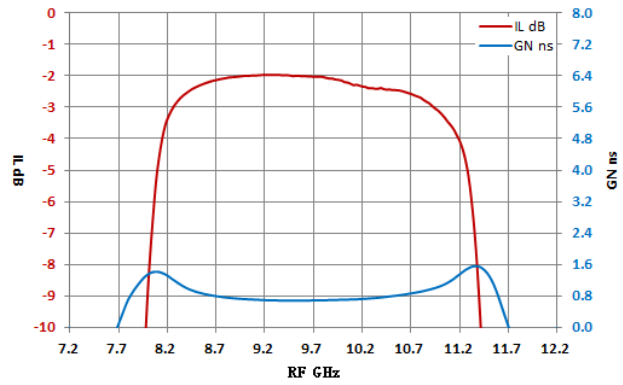
注意事项

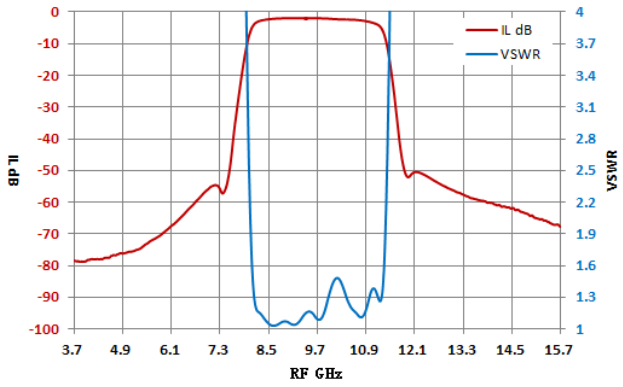
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

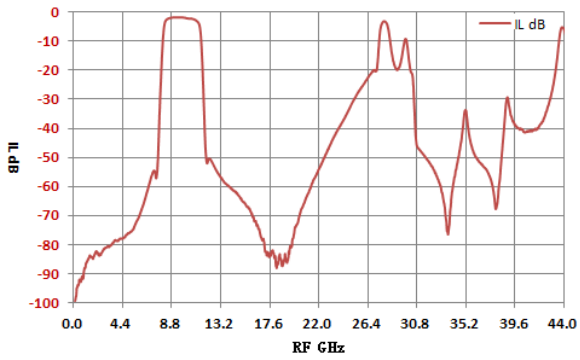
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



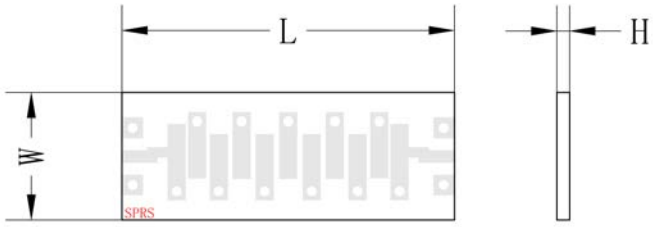
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.9	GHz
工作带宽	8.3-11.5	GHz
中心损耗	1.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-7.0GHz	dBc
带外抑制	30@12.7-24.0GHz	dBc

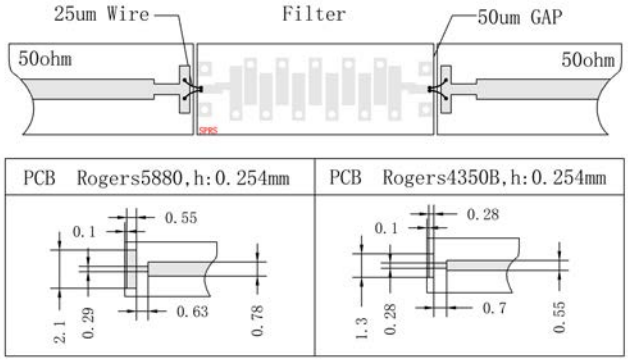
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.5，W：4.0，h：0.39

外形图：端口居中



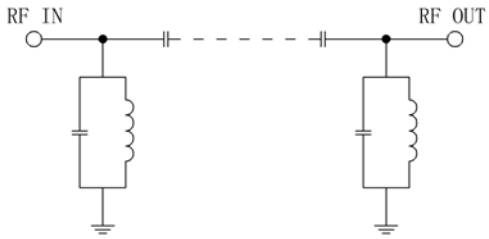
推荐装配图



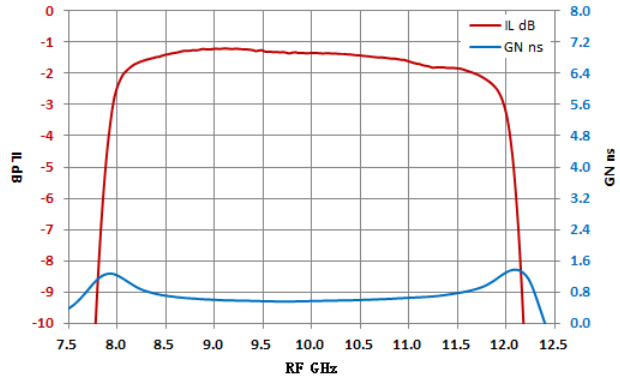
注意事项

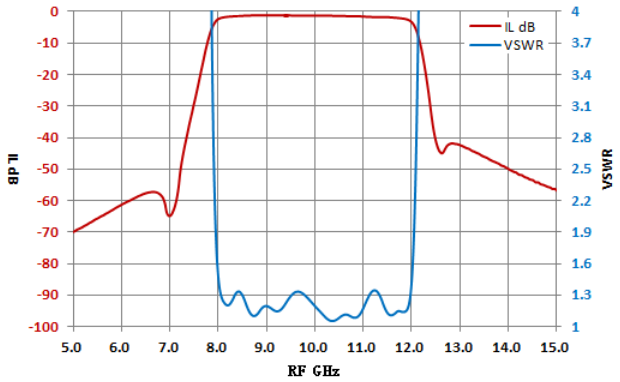
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

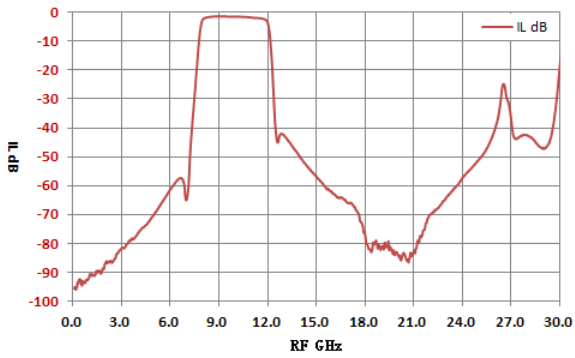
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

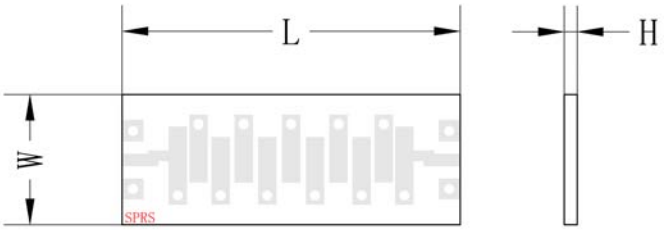
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	10.0	GHz
工作带宽	8.3-11.7	GHz
中心损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-7.0GHz	dBc
带外抑制	35@13.1-25.0GHz	dBc

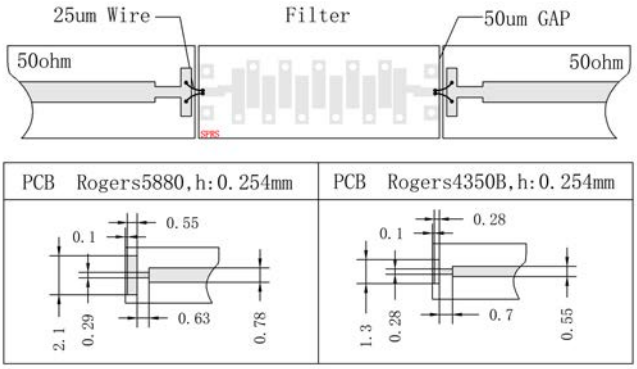
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：8.0，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

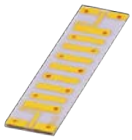
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

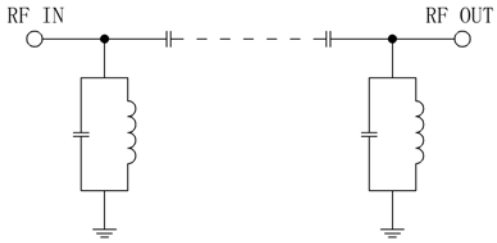
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

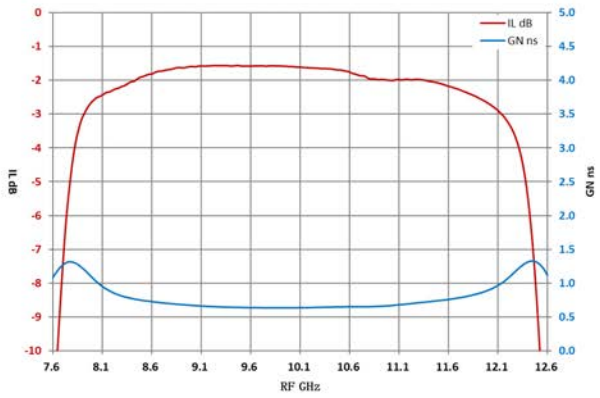
参考图

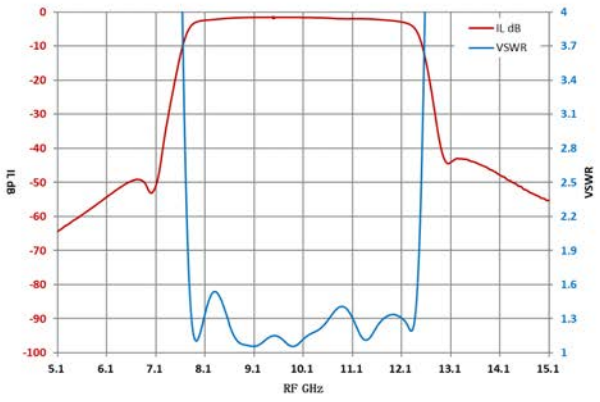


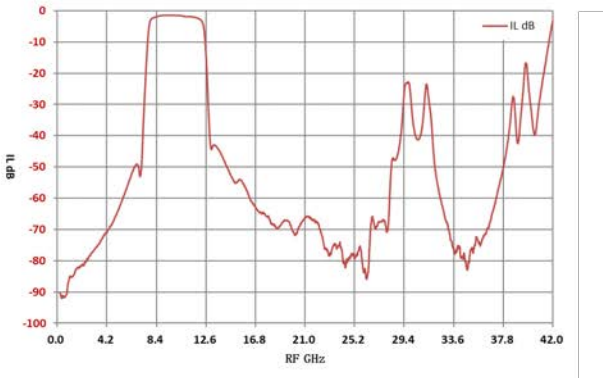
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

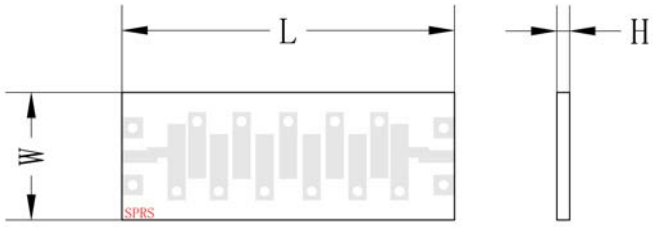
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.2	GHz
工作带宽	8.4-10.0	GHz
中心损耗	2.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-7.5GHz	dBc
带外抑制	40@11.1-21.0GHz	dBc

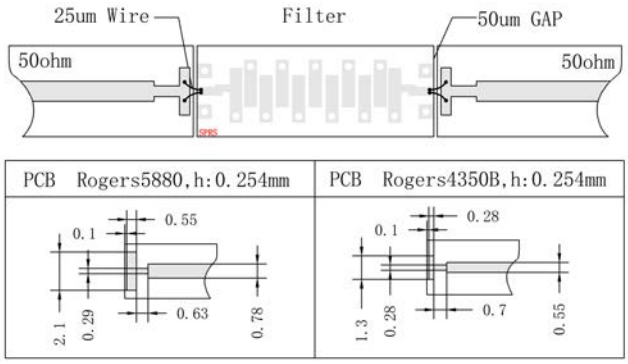
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



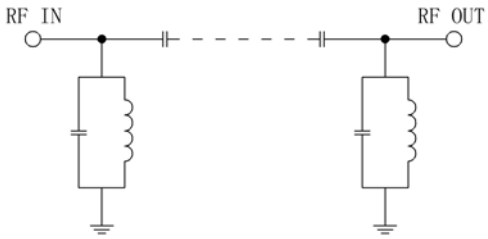
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

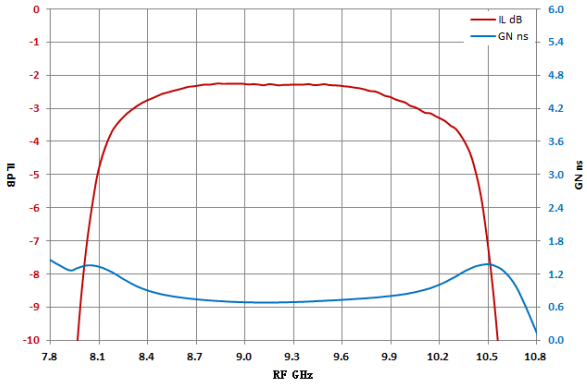
参考实物图

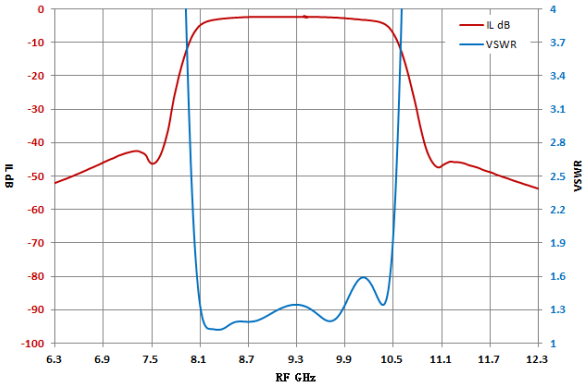


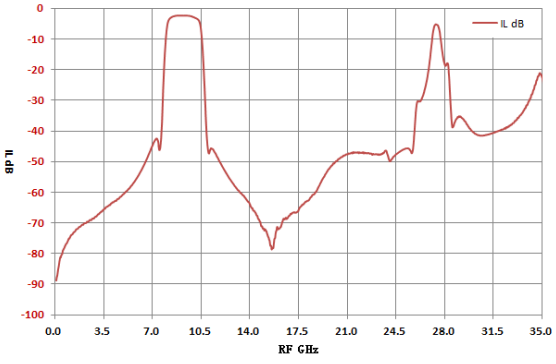
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



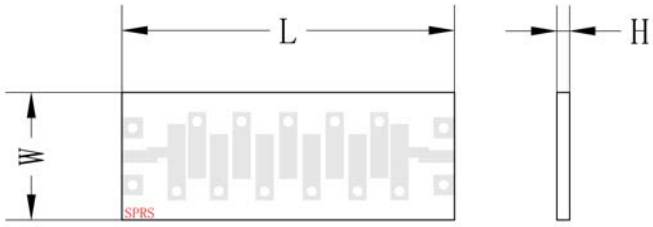
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.2	GHz
工作带宽	8.4-10.0	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	30@DC-7.5GHz	dBc
带外抑制	40@11.4-19.0GHz	dBc

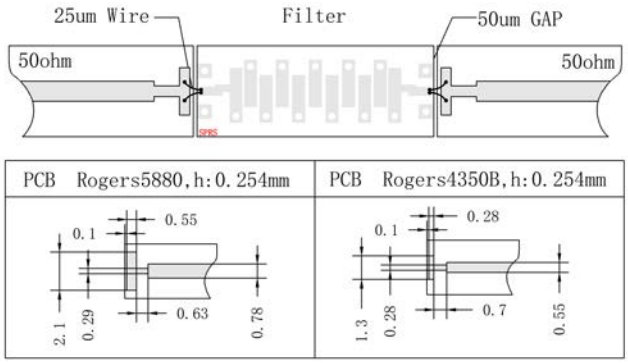
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：4.5，h：0.26

外形图：端口居中



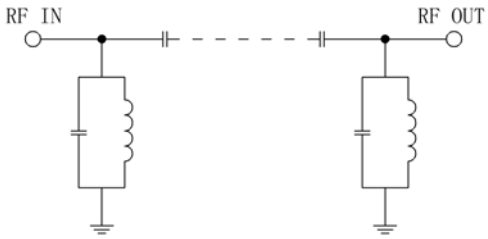
推荐装配图



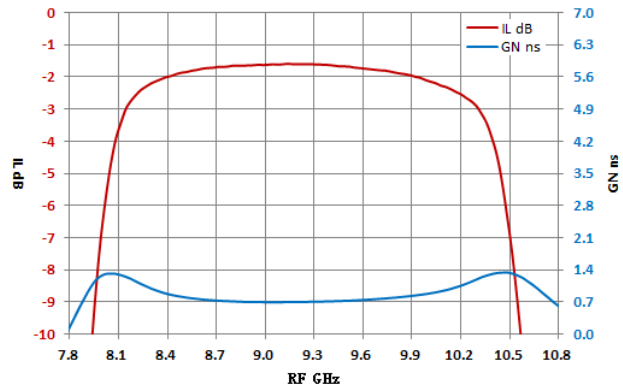
注意事项

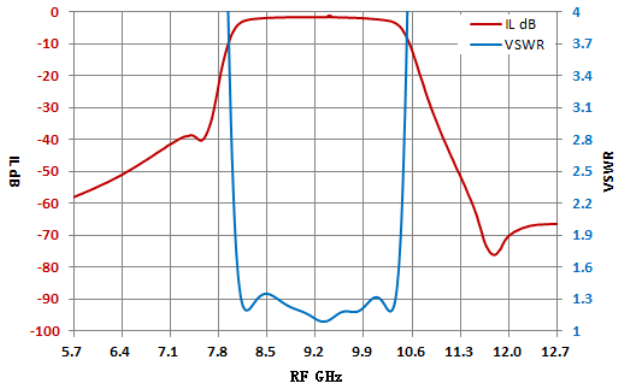
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

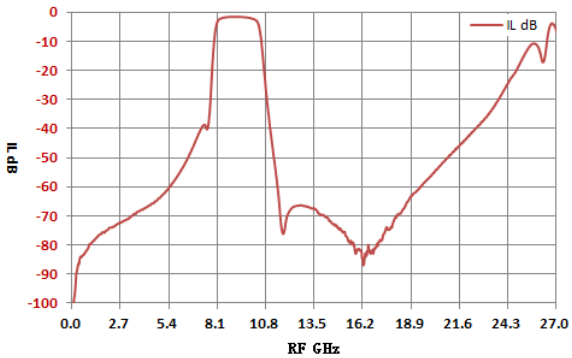
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

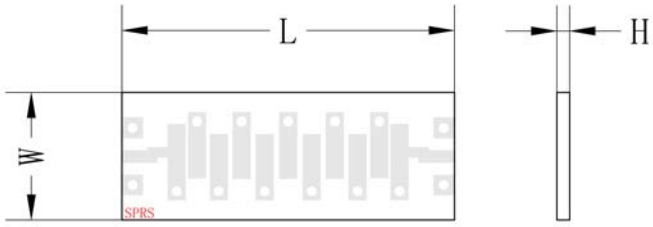
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.3	GHz
工作带宽	8.4-10.2	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-7.0GHz	dBc
带外抑制	40@12.6-21.0GHz	dBc

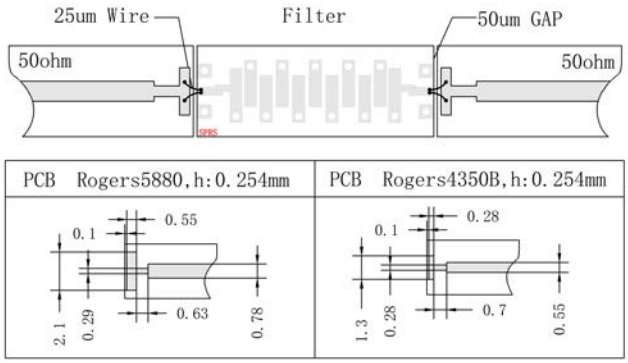
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



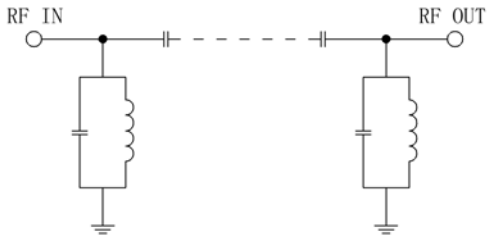
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

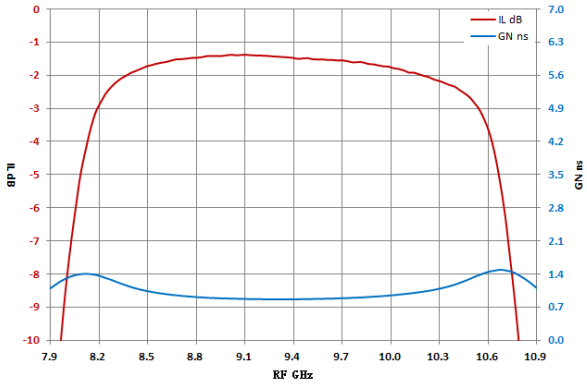
参考实物图

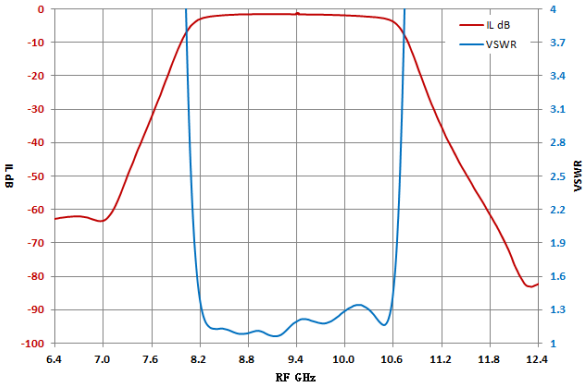


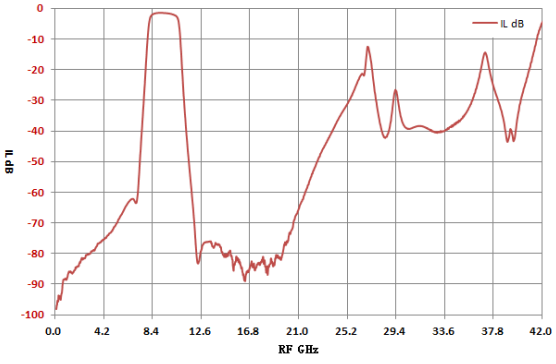
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



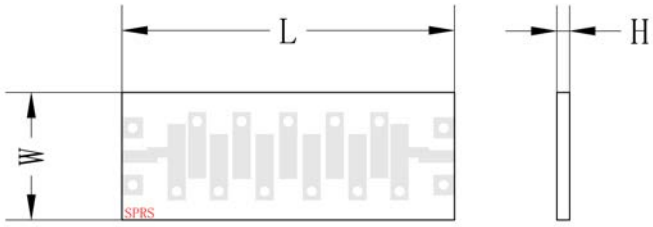
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.0	GHz
工作带宽	8.5-9.5	GHz
中心损耗	3.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-7.5GHz	dBc
带外抑制	40@10.6-19.0GHz	dBc

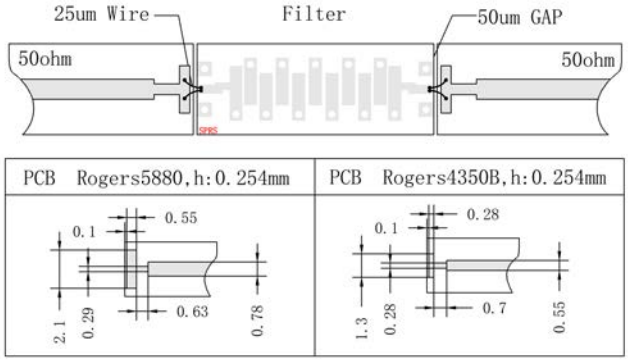
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



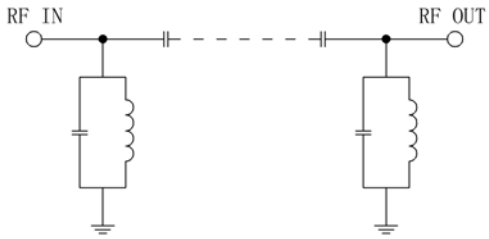
推荐装配图



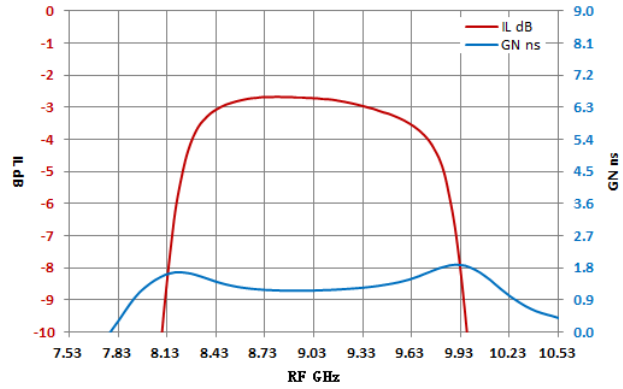
注意事项

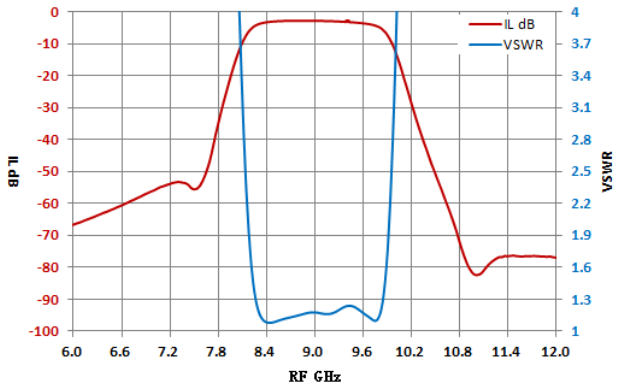
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

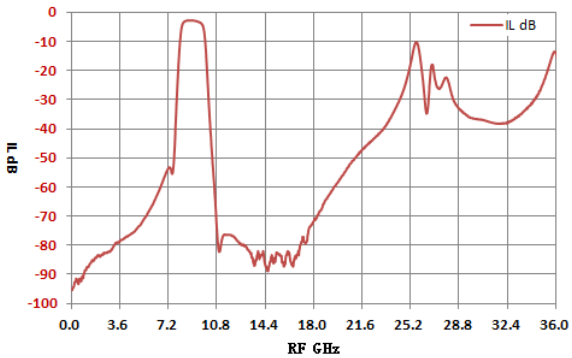
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

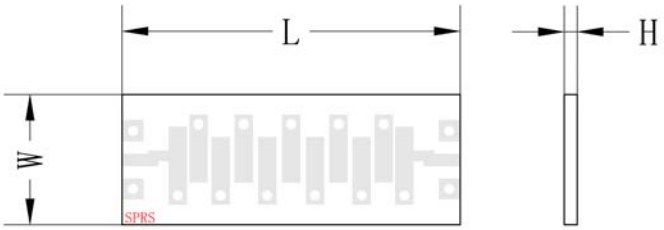
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.1	GHz
工作带宽	8.6-9.6	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.6	ns
带外抑制	40@DC-7.7GHz	dBc
带外抑制	40@10.4-22.0GHz	dBc

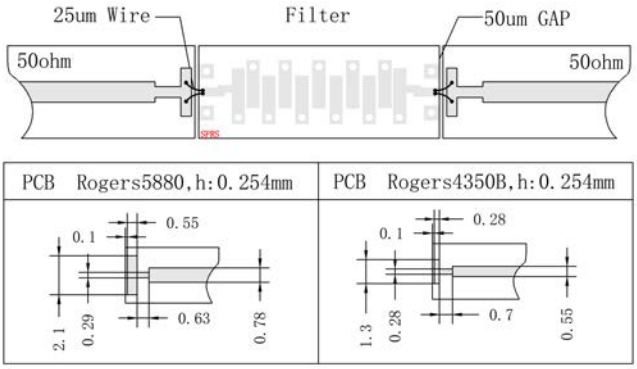
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：9.0，W：3.5，h：0.39

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.61mm,端口可互换;

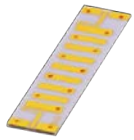
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

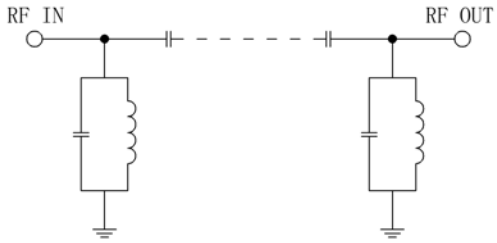
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

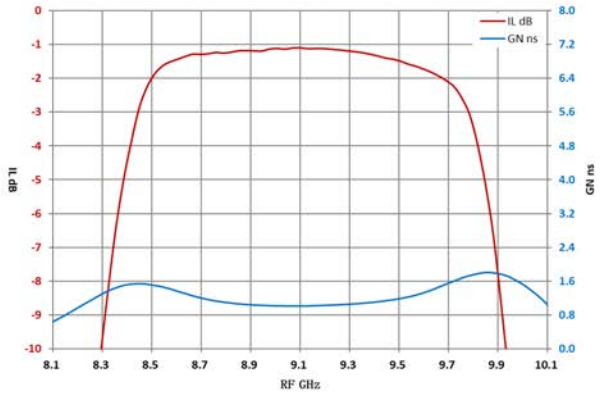
参考图

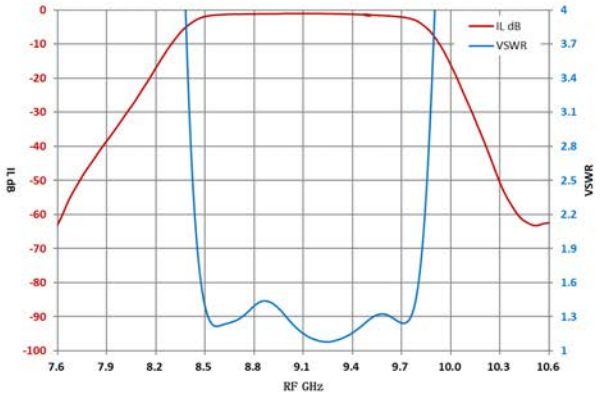


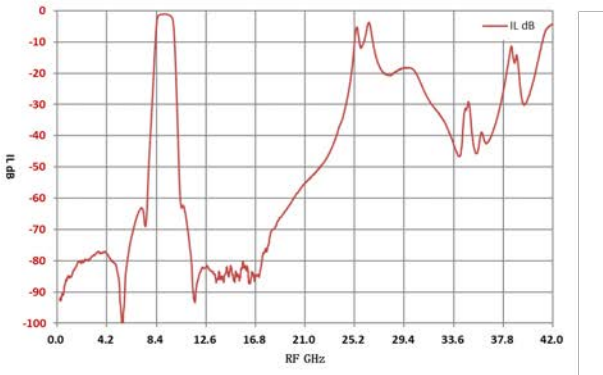
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



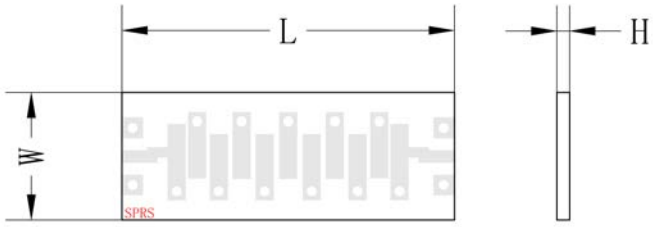
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	11.0	GHz
工作带宽	8.6-13.4	GHz
中心损耗	1.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-5.0GHz	dBc
带外抑制	40@15.3-27.0GHz	dBc

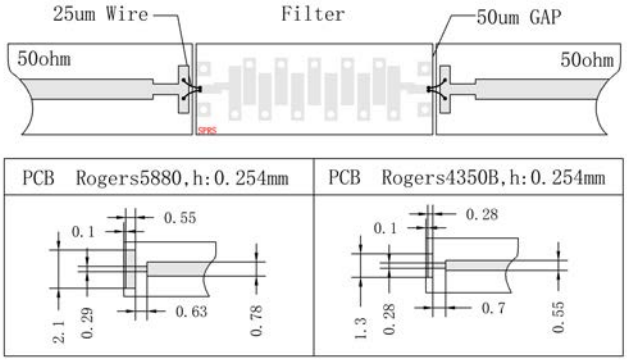
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



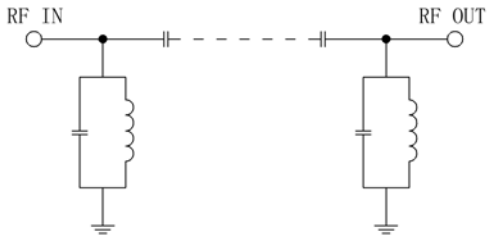
推荐装配图



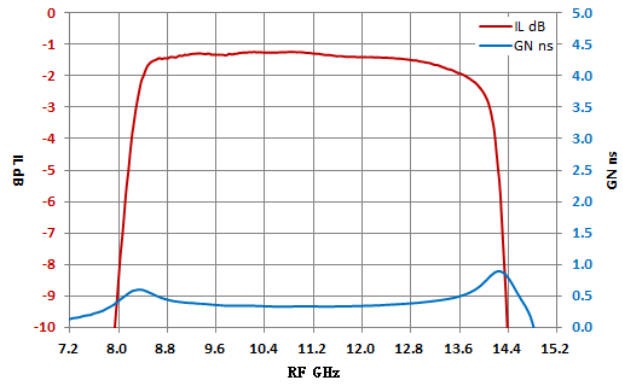
注意事项

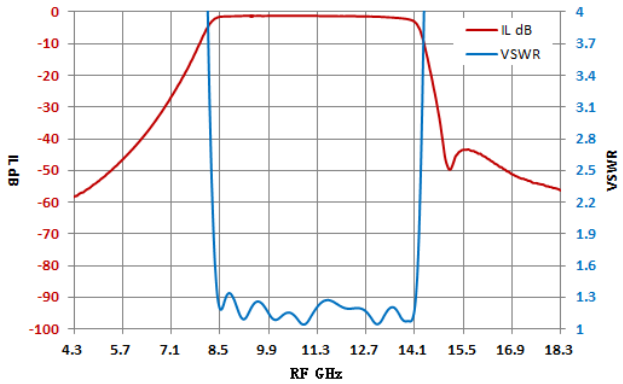
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

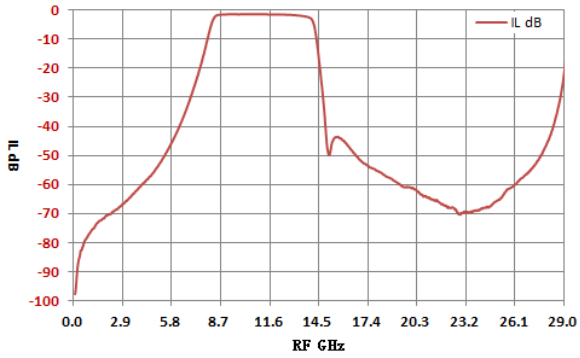
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



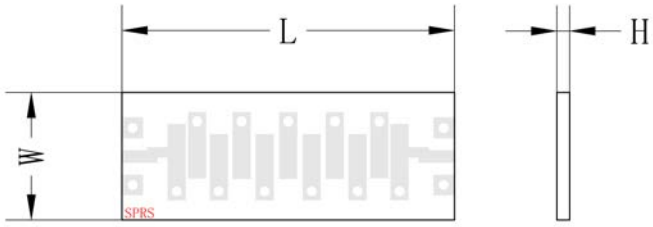
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	8.8	GHz
工作带宽	8.7-8.9	GHz
中心损耗	5.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-7.9GHz	dBc
带外抑制	40@9.5-21.0GHz	dBc

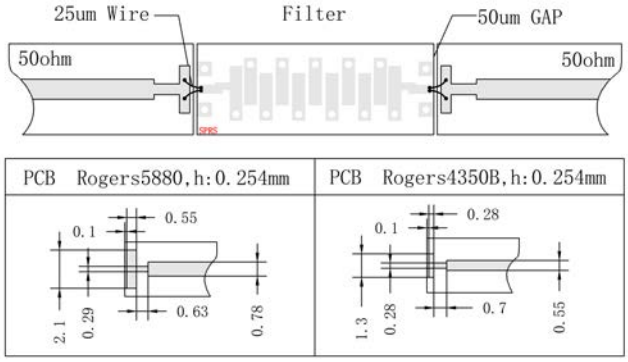
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.0，W：4.5，h：0.26

外形图：端口居中



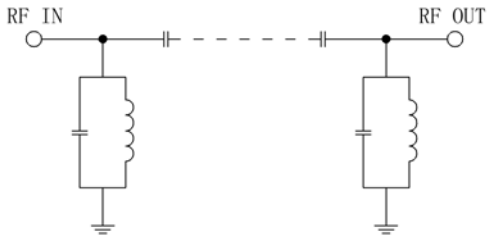
推荐装配图



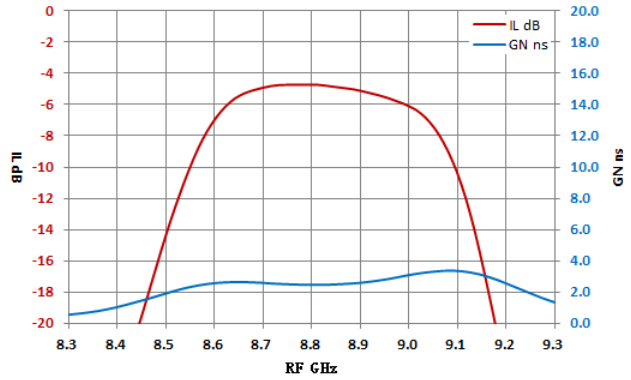
注意事项

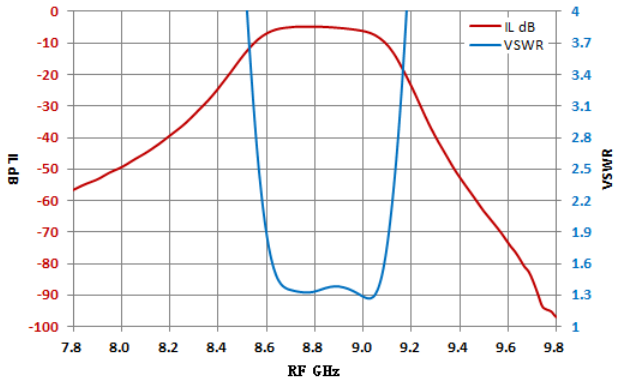
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

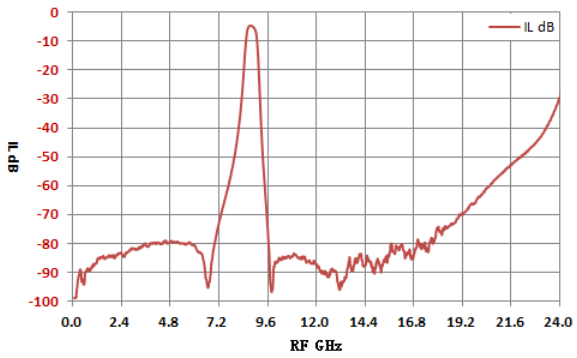
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

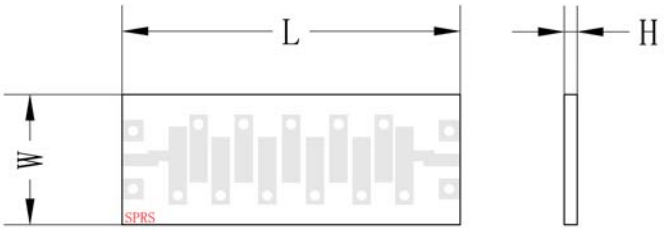
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	8.95	GHz
工作带宽	8.7-9.2	GHz
中心损耗	3.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.6	ns
带外抑制	35@DC-8.0GHz	dBc
带外抑制	30@10.0-18.0GHz	dBc

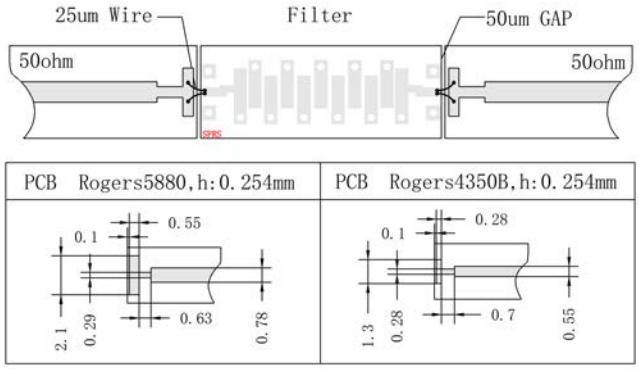
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：7.0，W：4.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

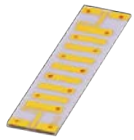
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

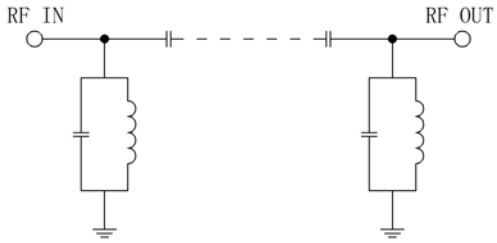
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

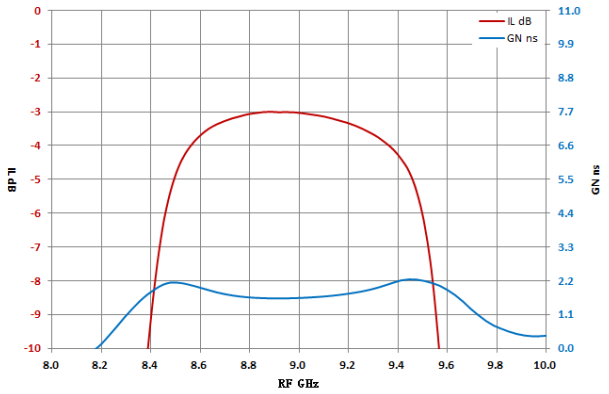
参考图

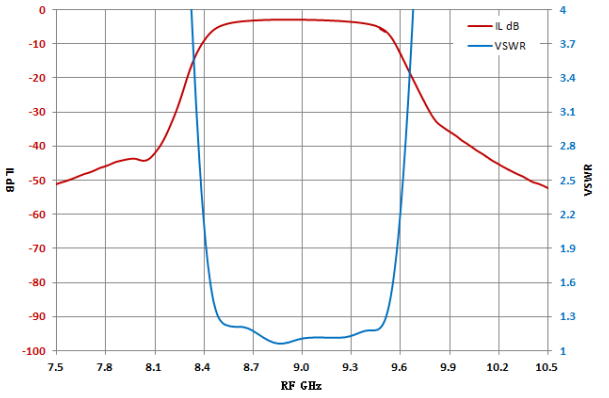


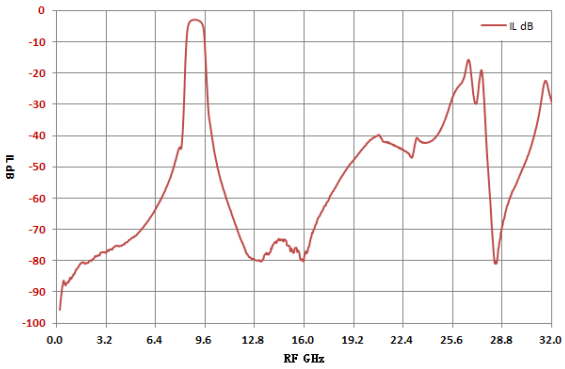
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



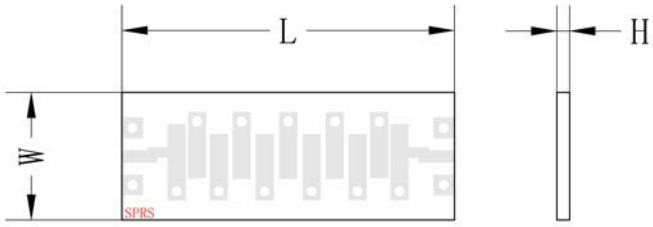
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	10.3	GHz
工作带宽	8.8-11.8	GHz
中心损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-5.8GHz	dBc
带外抑制	30@13.5-25.0GHz	dBc

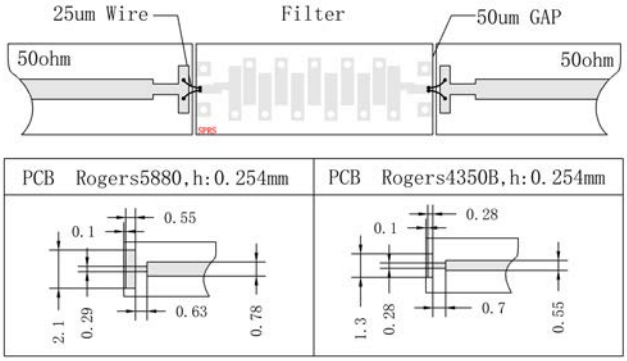
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



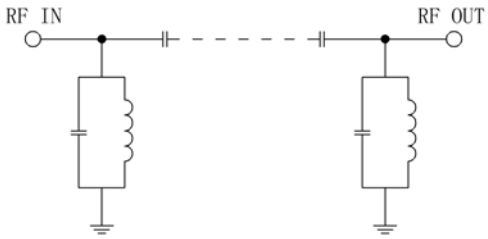
推荐装配图



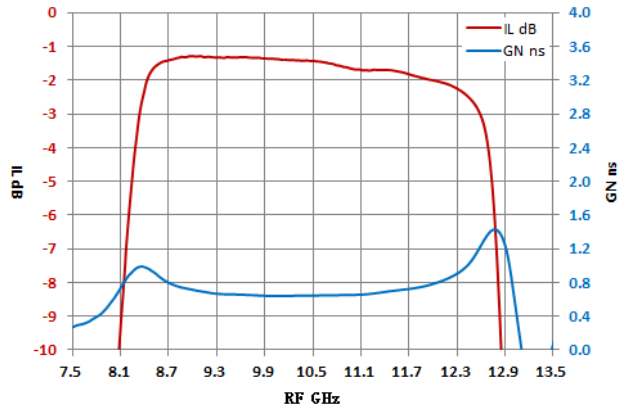
注意事项

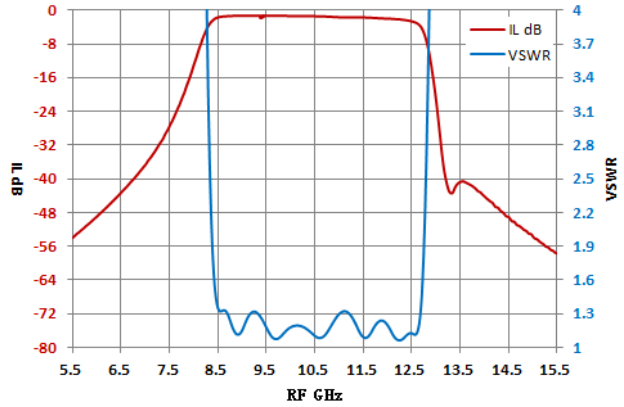
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

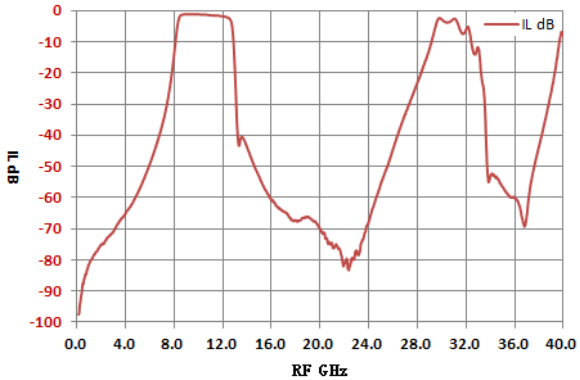
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



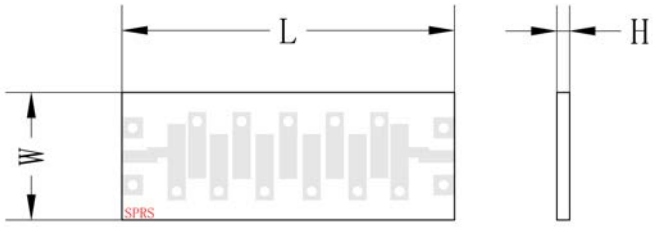
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.2	GHz
工作带宽	8.9-9.5	GHz
中心损耗	2.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-7.7GHz	dBc
带外抑制	40@11.0-15.0GHz	dBc

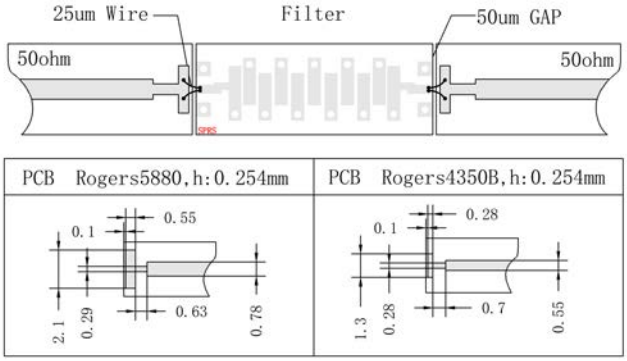
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：4.5，h：0.26

外形图：端口居中



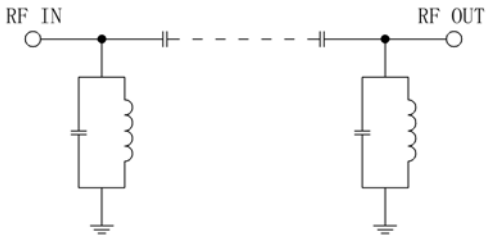
推荐装配图



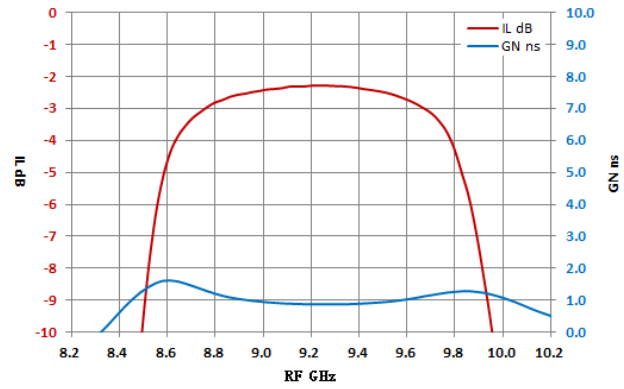
注意事项

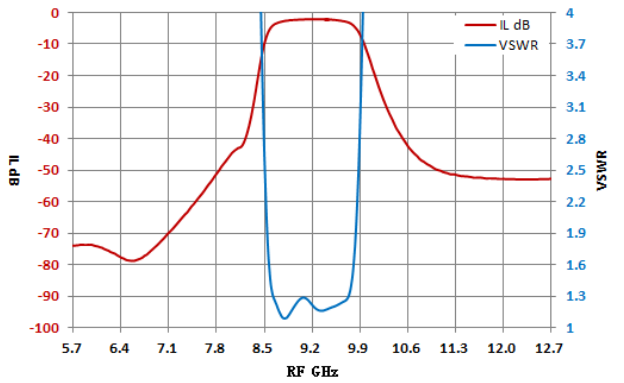
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

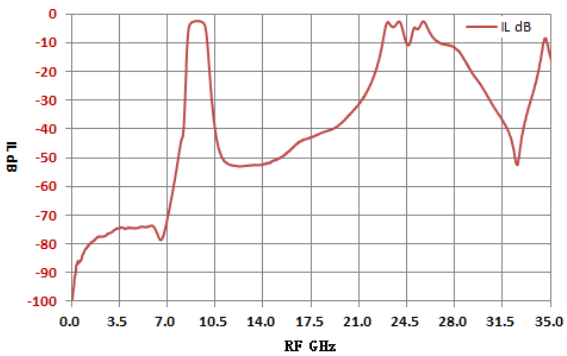
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



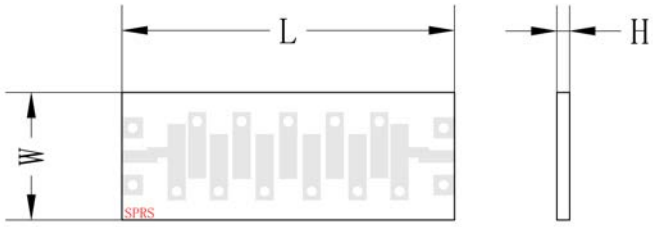
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.7	GHz
工作带宽	8.9-10.4	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	30@DC-8.0GHz	dBc
带外抑制	40@11.6-20.0GHz	dBc

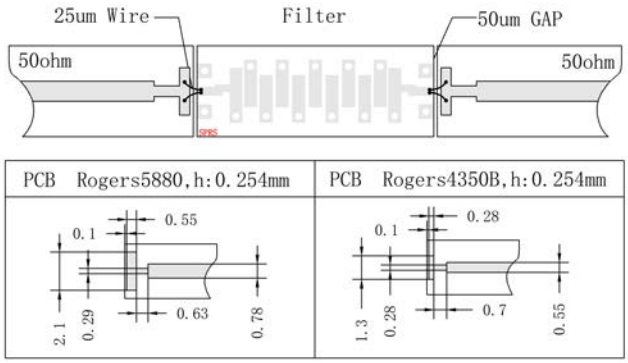
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：4.5，h：0.26

外形图：端口居中



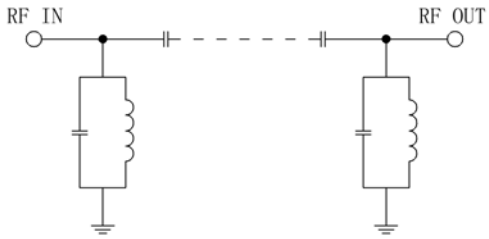
推荐装配图



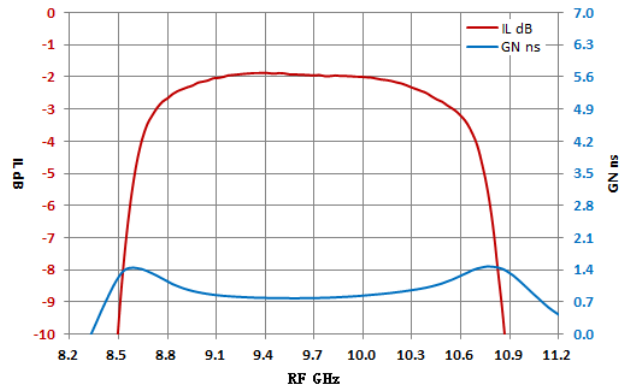
注意事项

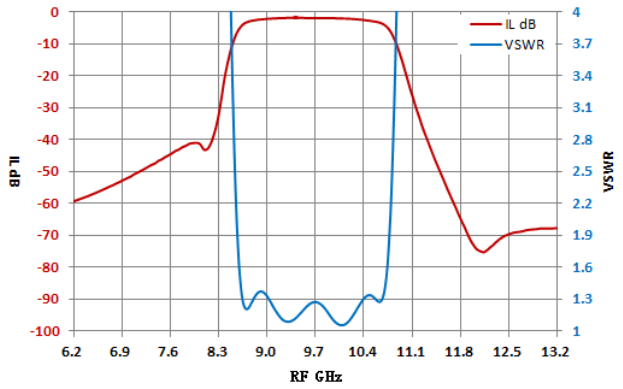
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

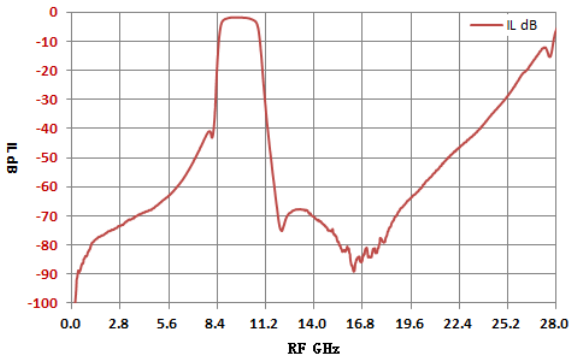
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

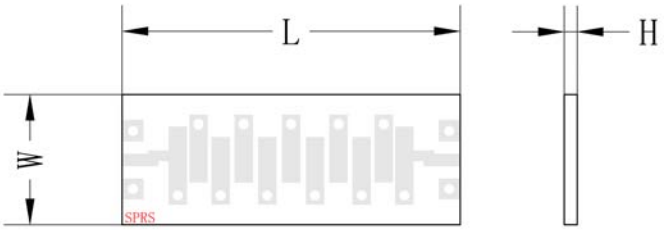
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.4	GHz
工作带宽	9.0-9.8	GHz
中心损耗	2.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-8.2GHz	dBc
带外抑制	40@10.5-23.0GHz	dBc

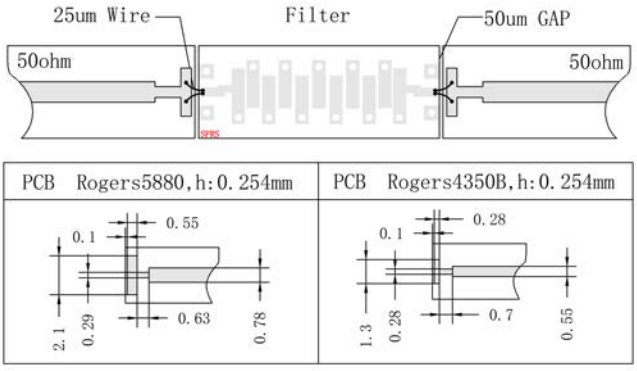
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：6.5，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

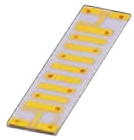
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

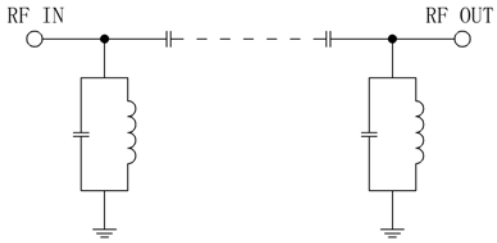
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

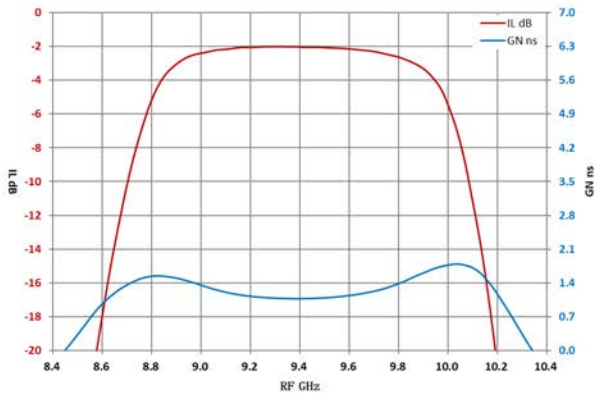
参考图

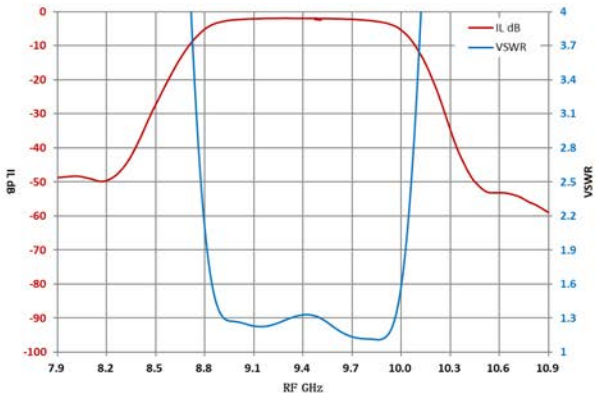


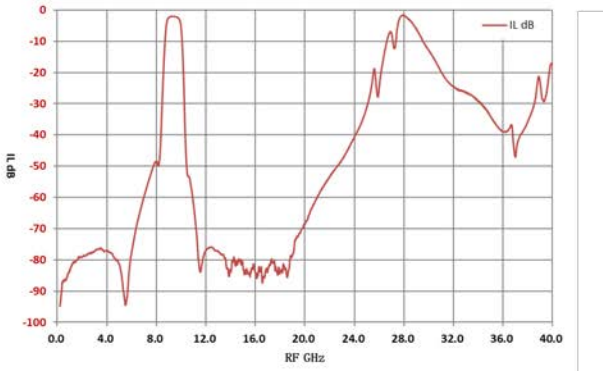
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

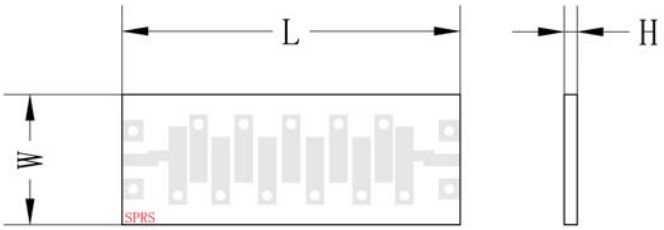
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.6	GHz
工作带宽	9.0-10.2	GHz
中心损耗	1.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.6	ns
带外抑制	40@DC-7.8GHz	dBc
带外抑制	40@11.4-24.0GHz	dBc

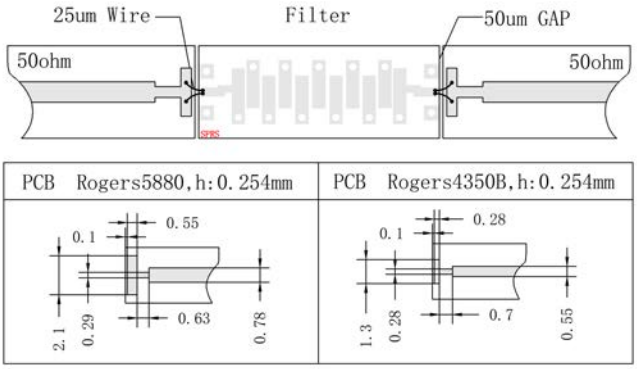
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：7.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

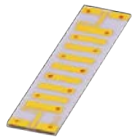
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

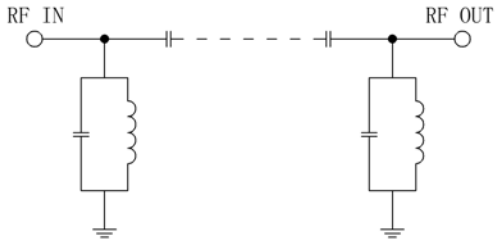
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

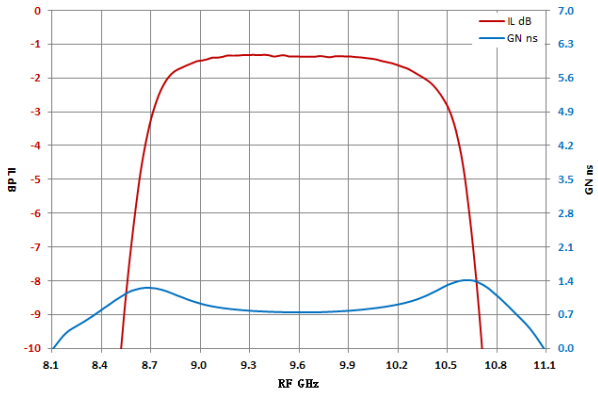
参考图

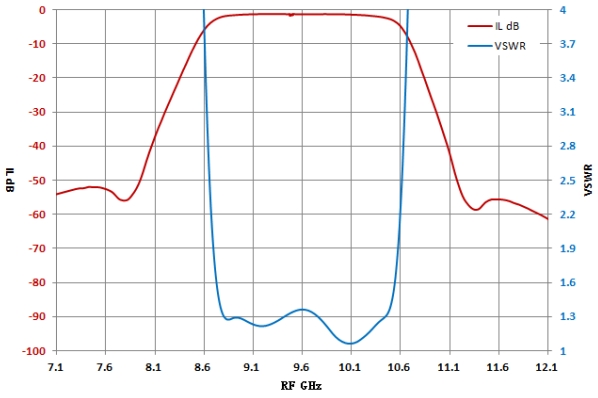


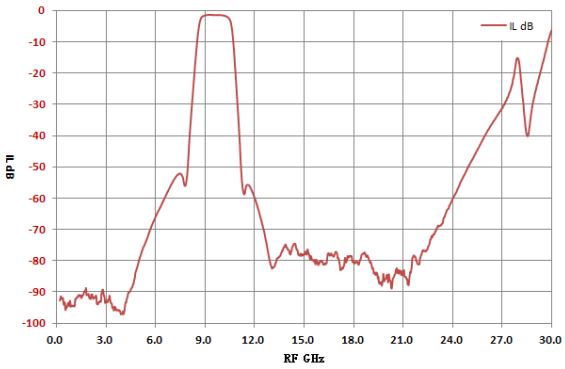
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



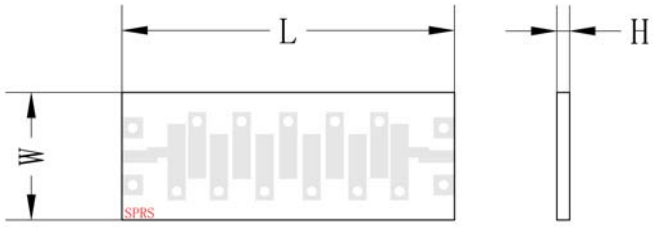
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.8	GHz
工作带宽	9.0-10.6	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	28@DC-8.0GHz	dBc
带外抑制	40@12.1-20.0GHz	dBc

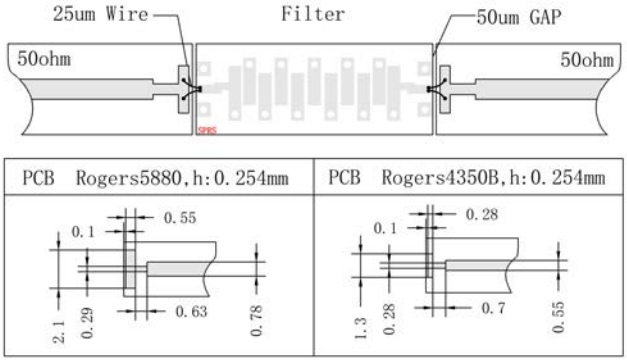
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



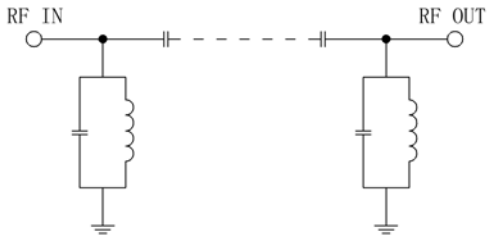
推荐装配图



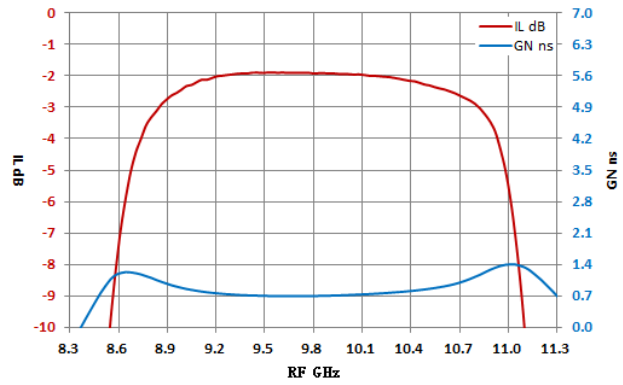
注意事项

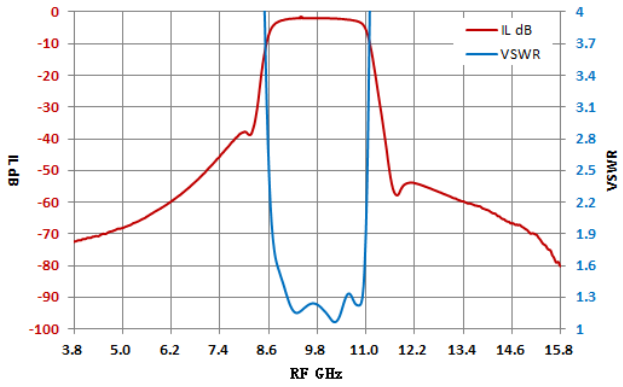
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

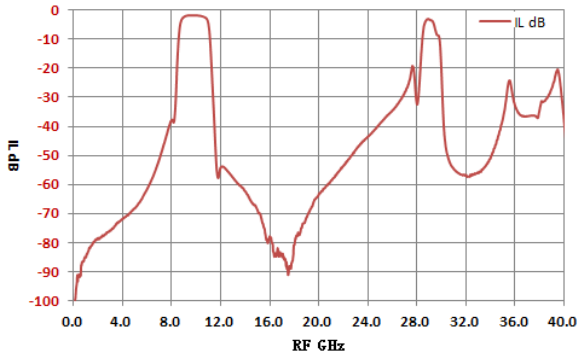
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



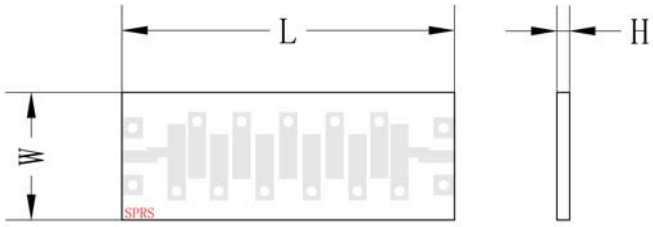
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	10.5	GHz
工作带宽	9.0-12.0	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-7.5GHz	dBc
带外抑制	40@14.0-27.0GHz	dBc

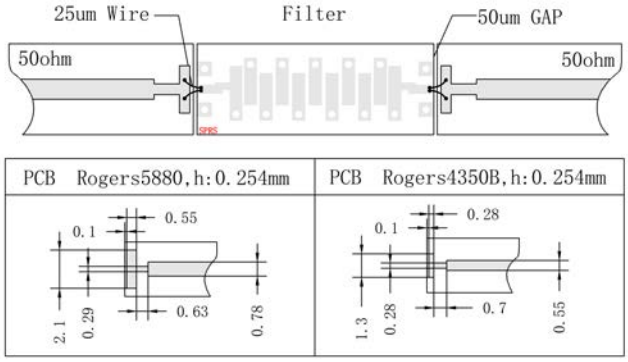
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



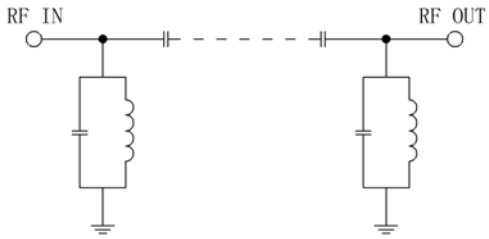
推荐装配图



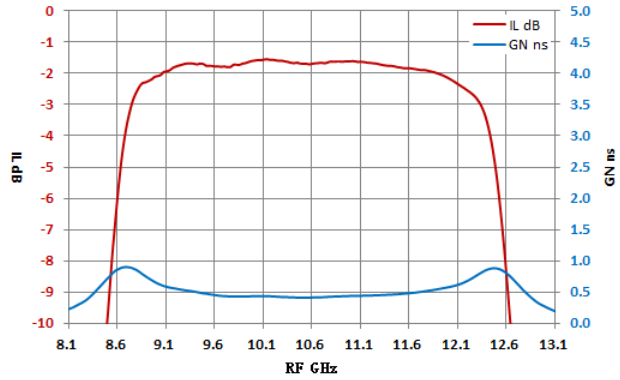
注意事项

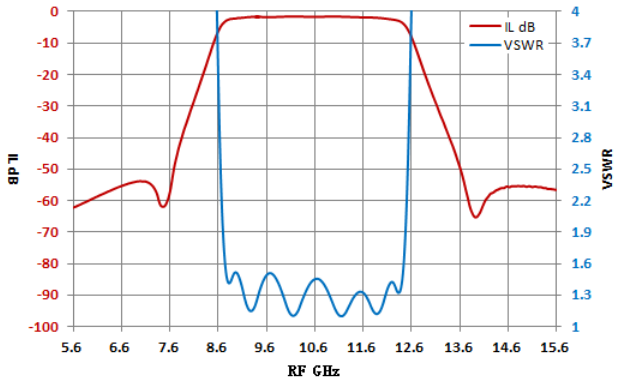
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

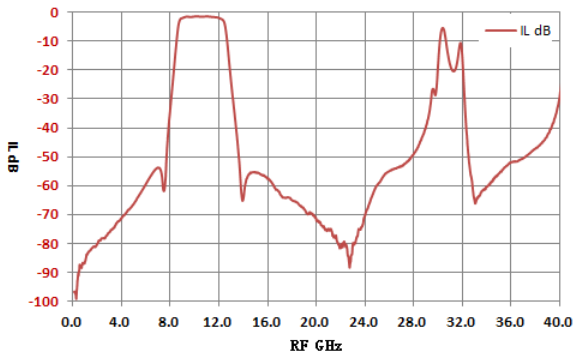
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

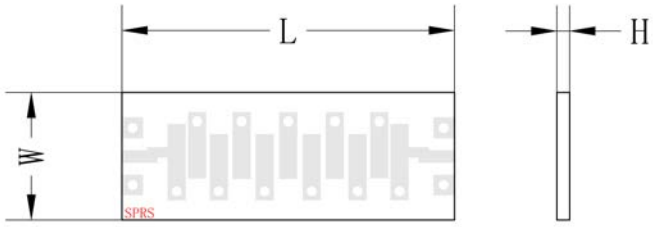
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	11.7	GHz
工作带宽	9.0-14.4	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-5.7GHz	dBc
带外抑制	40@17.2-29.0GHz	dBc

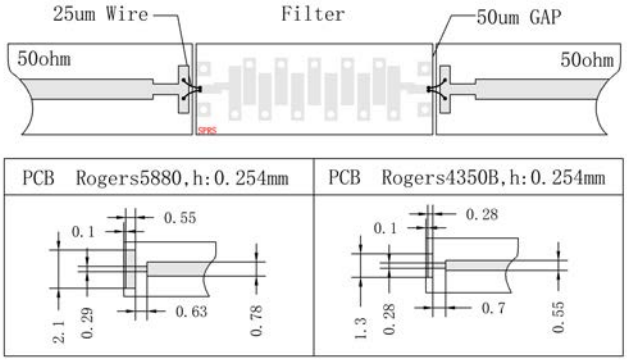
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



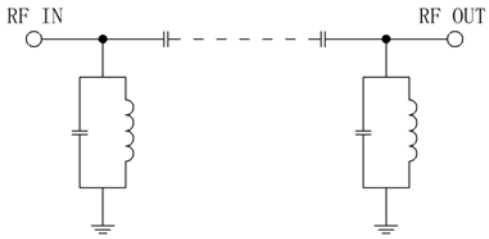
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

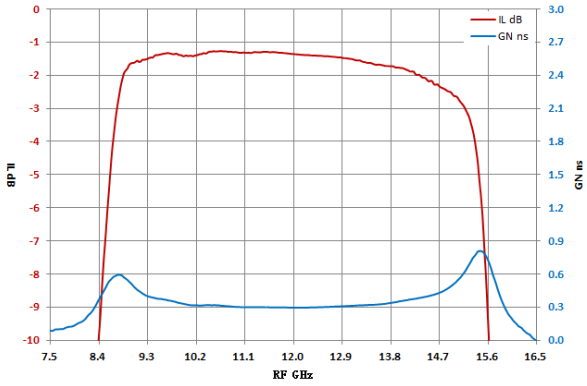
参考实物图

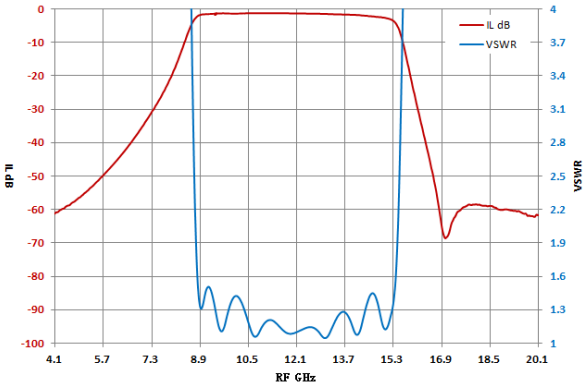


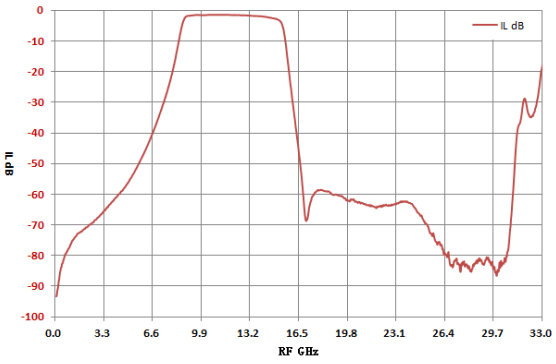
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

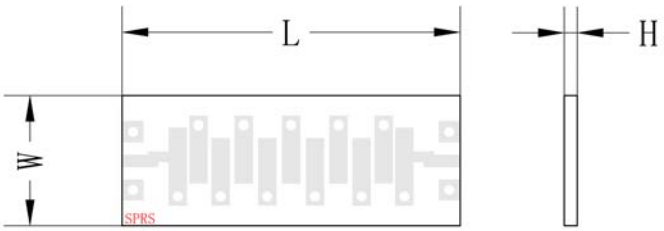
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.35	GHz
工作带宽	9.1-9.6	GHz
中心损耗	3.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-8.4GHz	dBc
带外抑制	40@10.3-24.0GHz	dBc

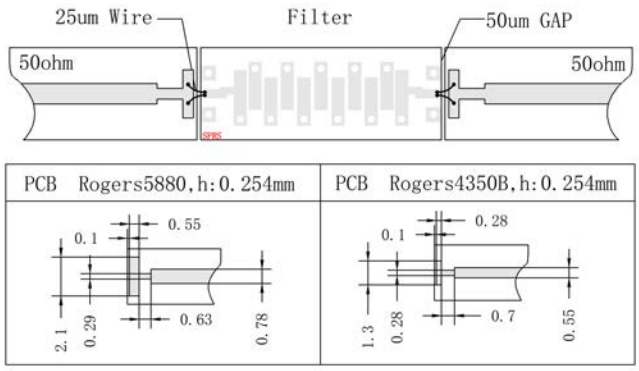
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：7.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

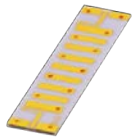
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

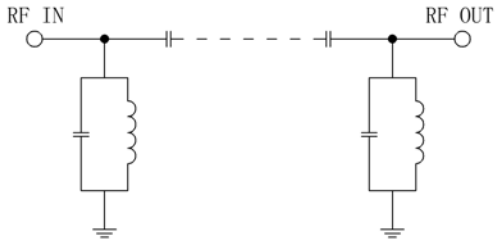
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

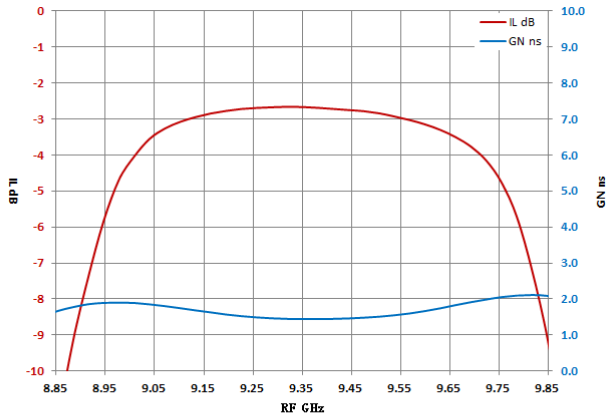
参考图

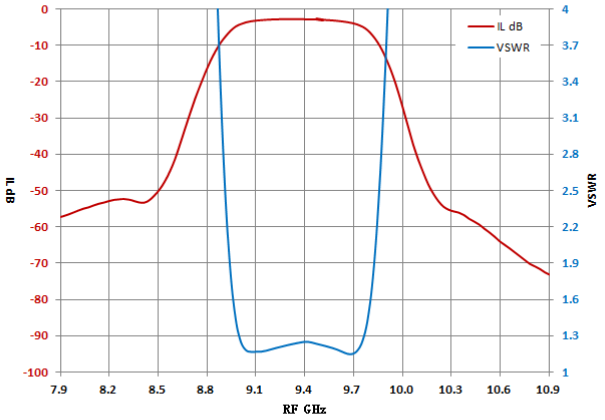


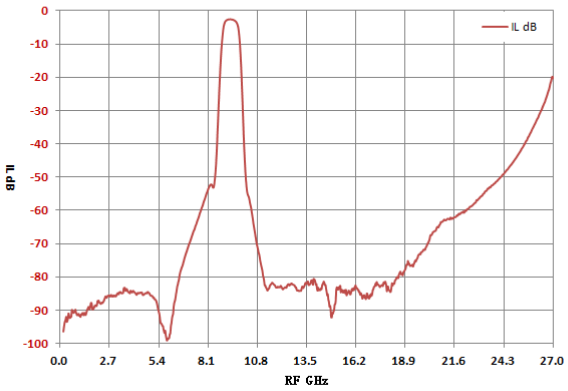
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

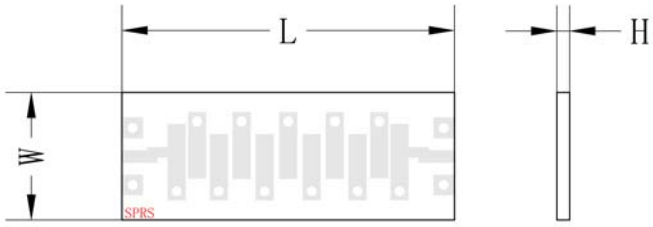
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.35	GHz
工作带宽	9.1-9.6	GHz
中心损耗	2.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-7.4GHz	dBc
带外抑制	40@10.4-23.0GHz	dBc

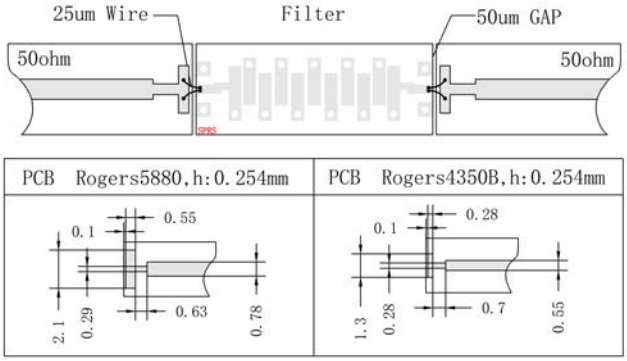
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：3.8，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



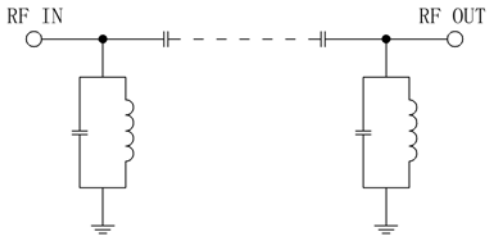
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

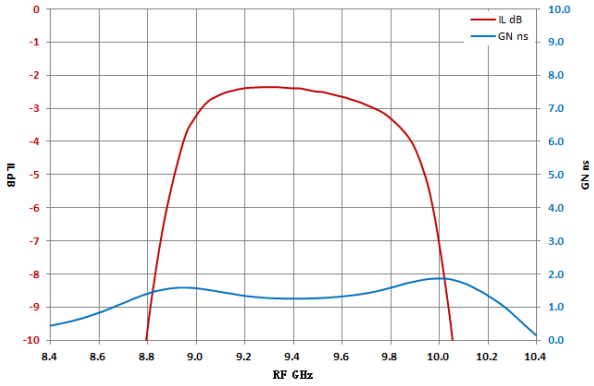
参考实物图

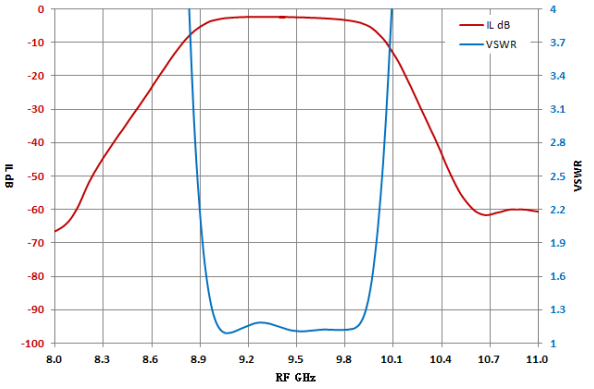


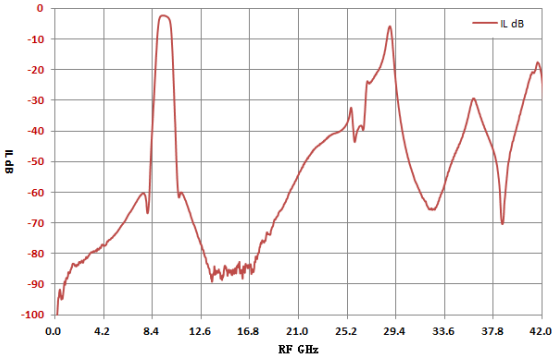
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



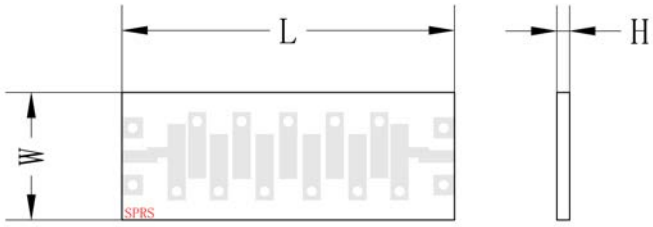
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	11.0	GHz
工作带宽	9.1-12.8	GHz
中心损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-7.0GHz	dBc
带外抑制	40@14.4-25.0GHz	dBc

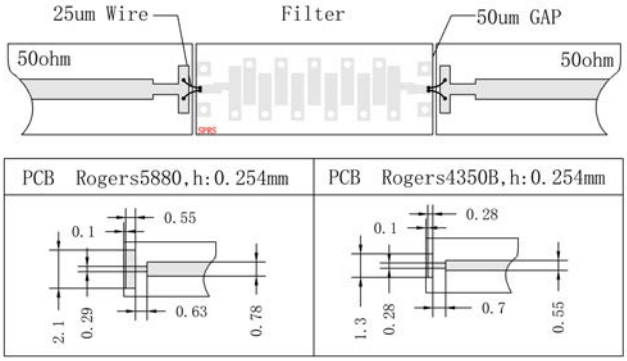
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



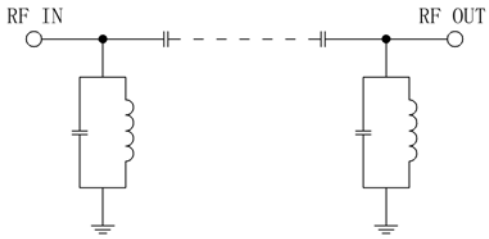
推荐装配图



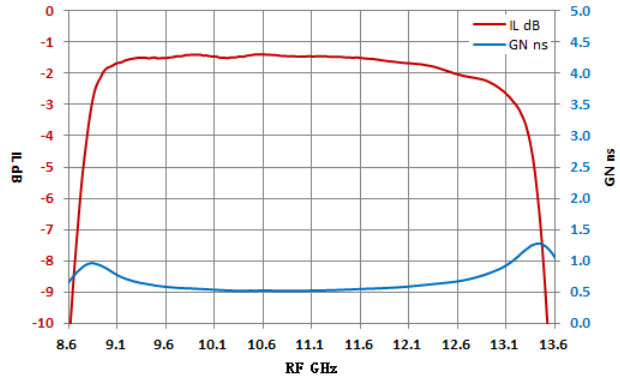
注意事项

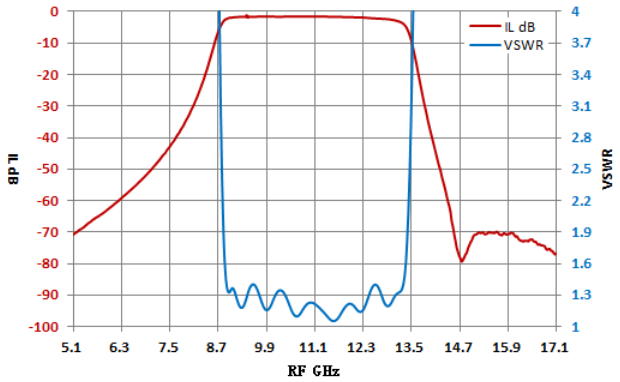
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

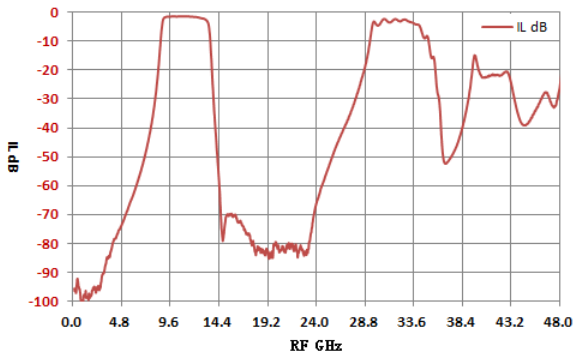
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



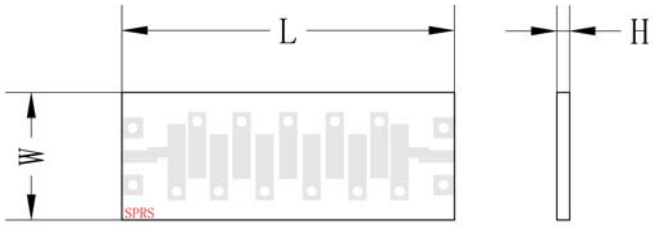
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.9	GHz
工作带宽	9.2-10.6	GHz
中心损耗	2.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-8.1GHz	dBc
带外抑制	40@11.9-23.0GHz	dBc

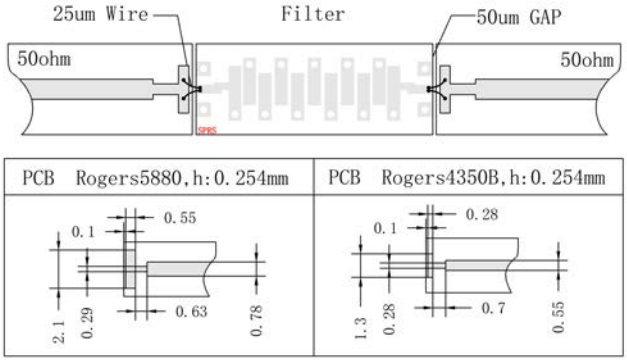
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.5，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



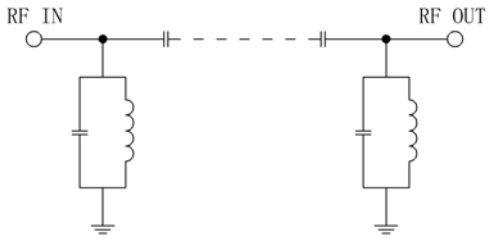
推荐装配图



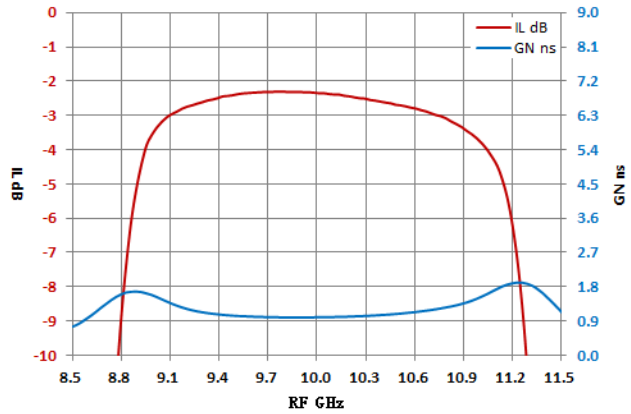
注意事项

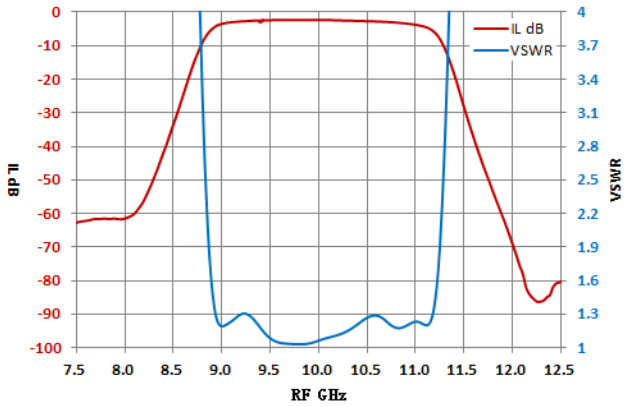
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

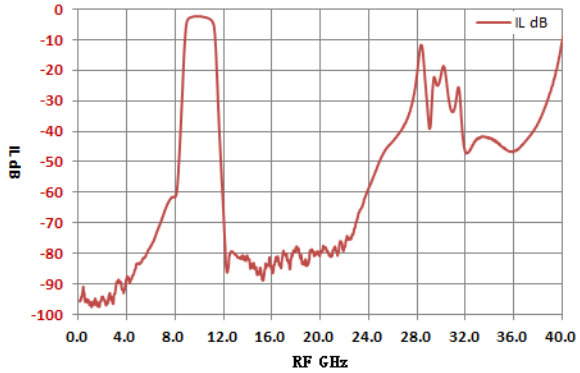
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



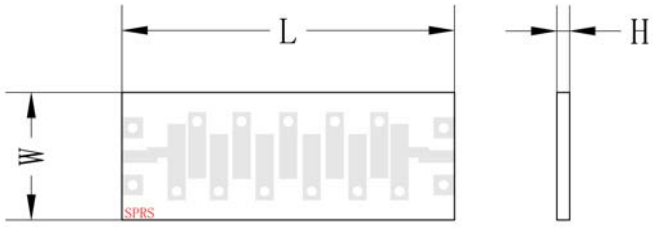
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	11.3	GHz
工作带宽	9.2-13.4	GHz
中心损耗	2.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-7.6GHz	dBc
带外抑制	40@15.6-27.0GHz	dBc

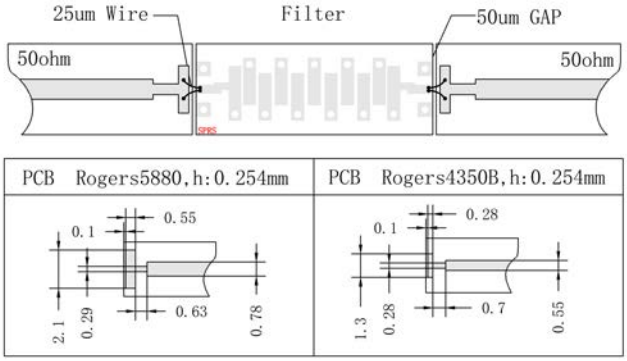
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



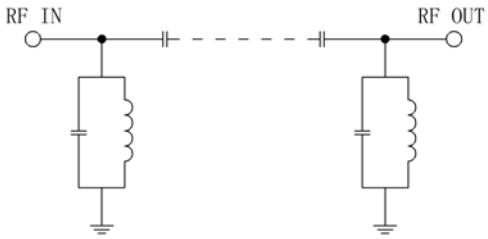
推荐装配图



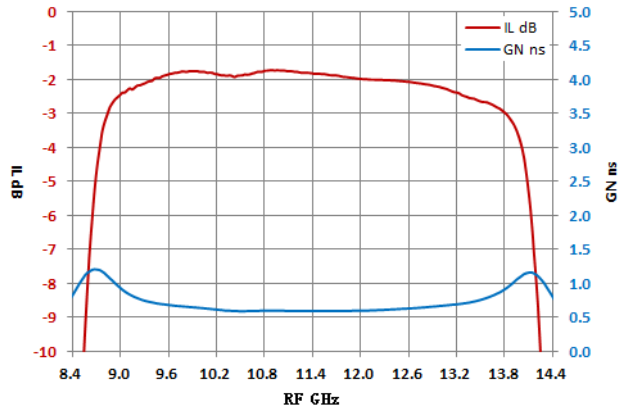
注意事项

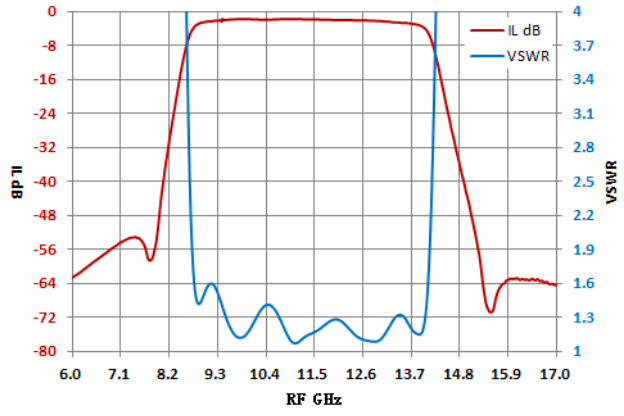
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

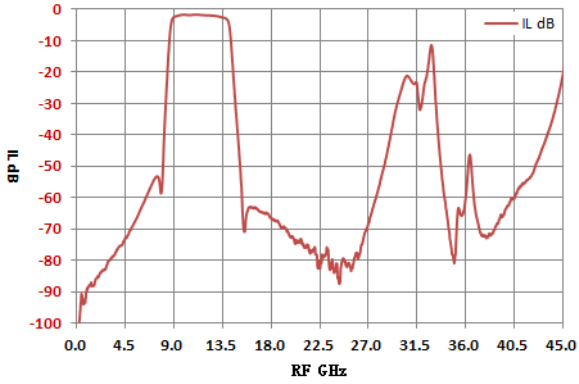
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

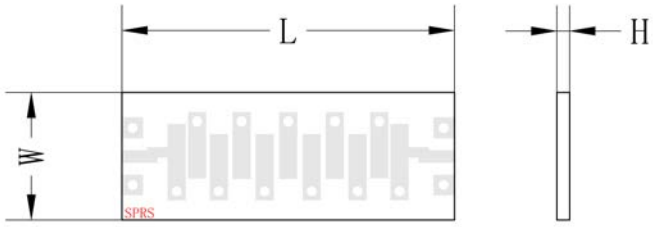
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.5	GHz
工作带宽	9.3-9.7	GHz
中心损耗	2.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-8.3GHz	dBc
带外抑制	40@10.3-25.0GHz	dBc

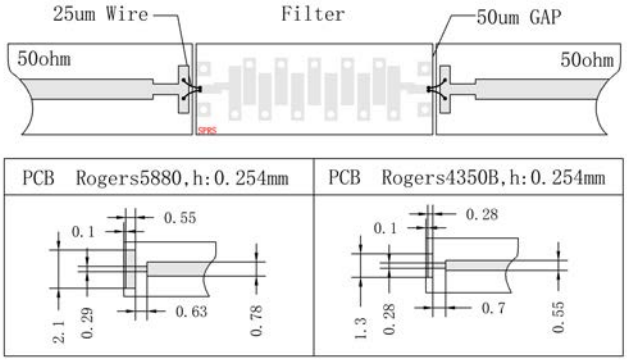
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



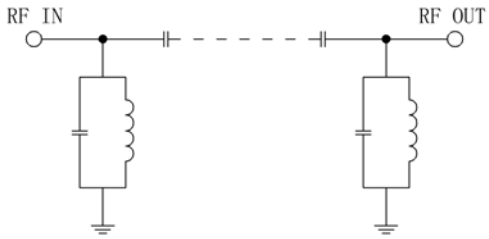
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

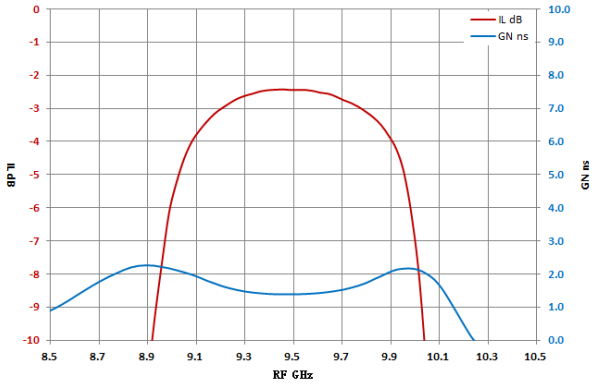
参考实物图

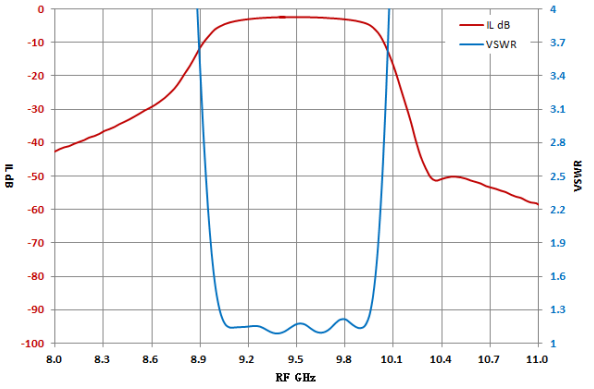


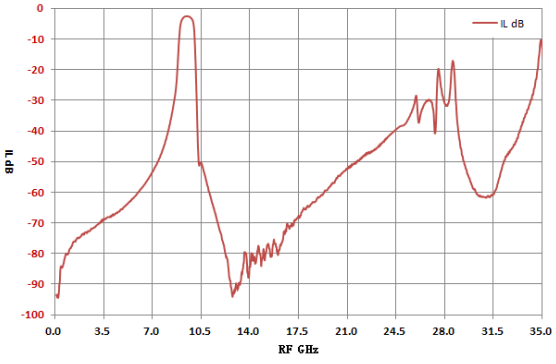
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



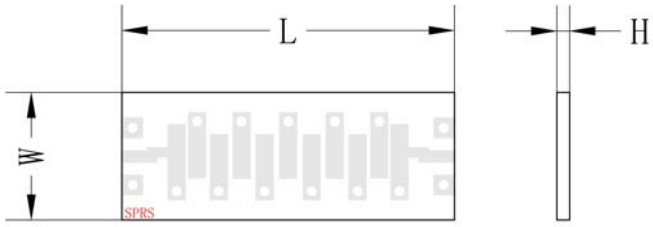
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.7	GHz
工作带宽	9.3-10.0	GHz
中心损耗	3.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-8.0GHz	dBc
带外抑制	40@11.6-16.0GHz	dBc

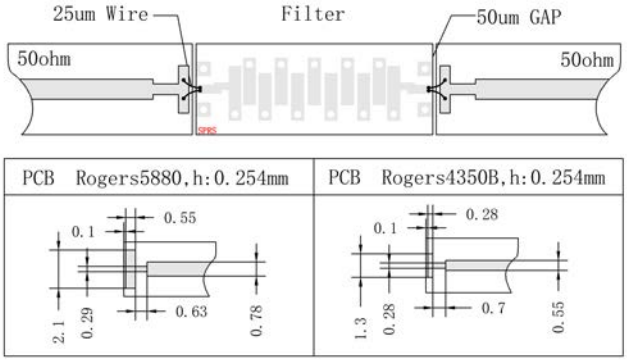
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：4.5，h：0.26

外形图：端口居中



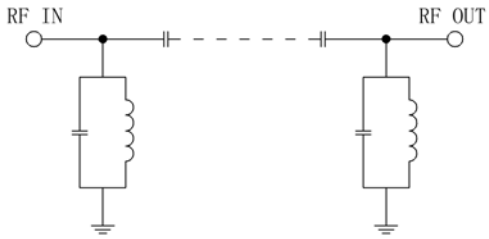
推荐装配图



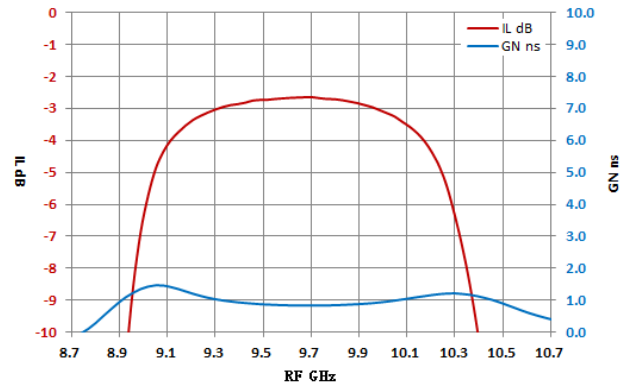
注意事项

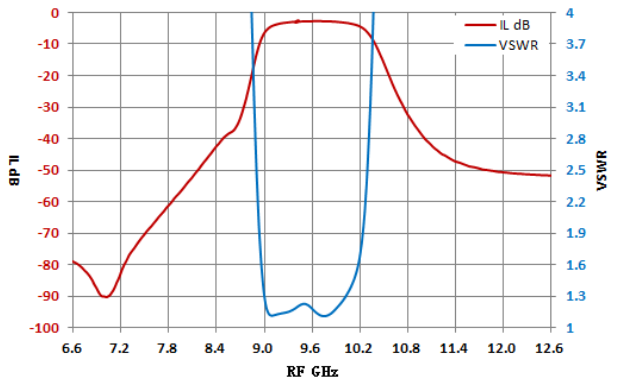
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

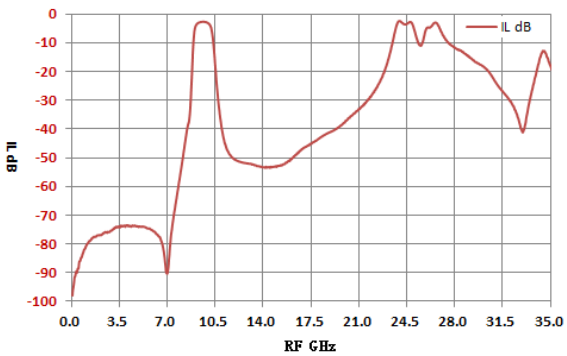
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

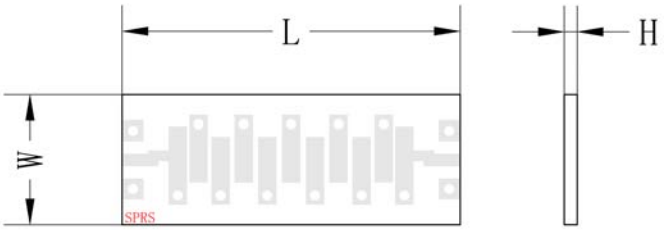
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.7	GHz
工作带宽	9.3-10.1	GHz
中心损耗	1.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-8.2GHz	dBc
带外抑制	40@11.0-24.0GHz	dBc

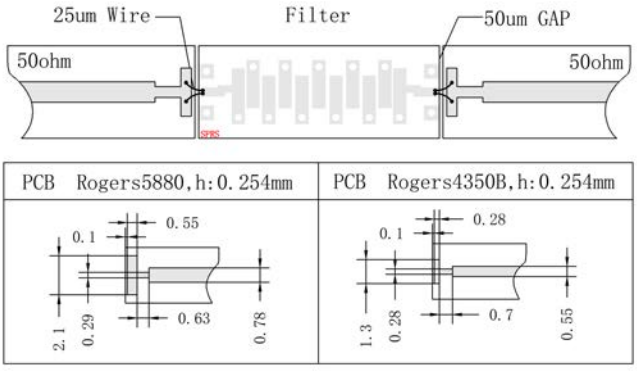
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：9.0，W：3.0，h：0.39

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.61mm,端口可互换;

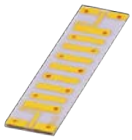
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

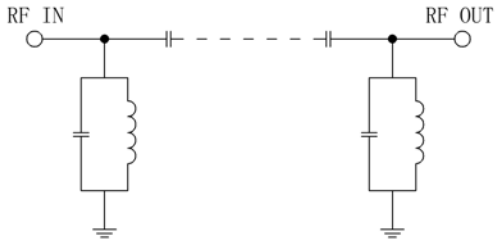
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

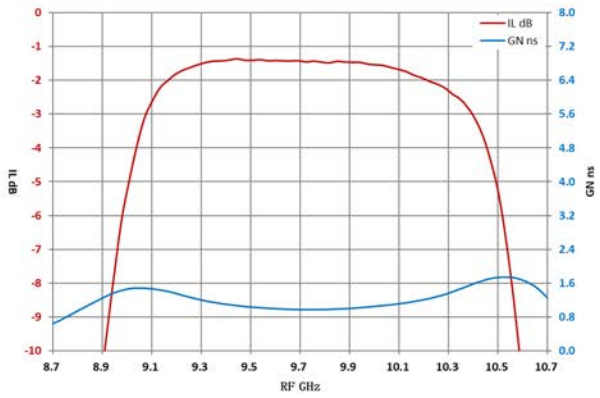
参考图

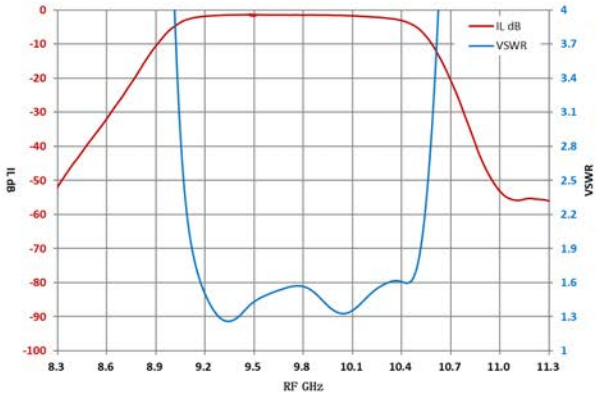


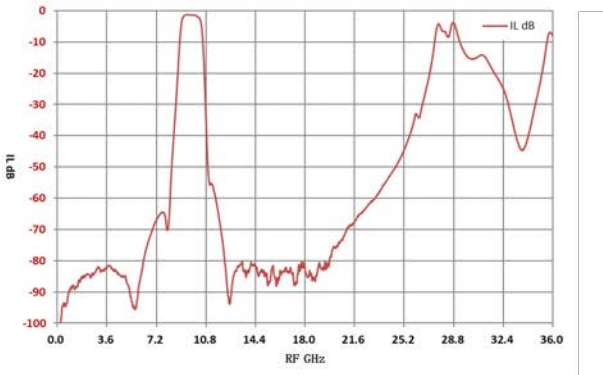
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

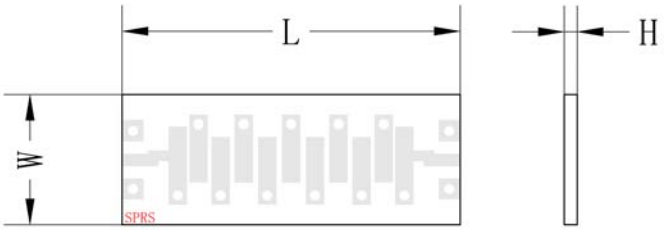
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	10.0	GHz
工作带宽	9.3-10.7	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.6	ns
带外抑制	45@DC-8.0GHz	dBc
带外抑制	50@12.2-24.0GHz	dBc

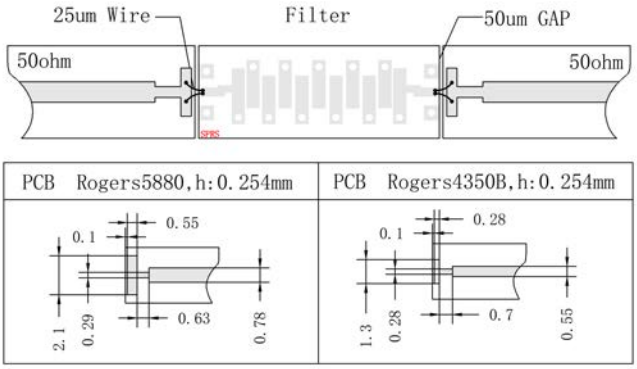
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：7.5，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

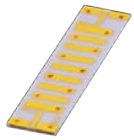
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

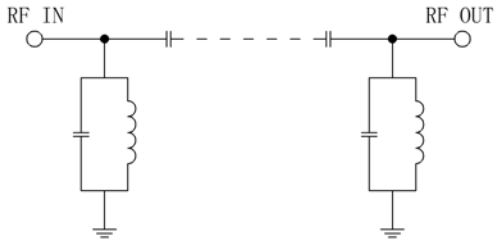
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

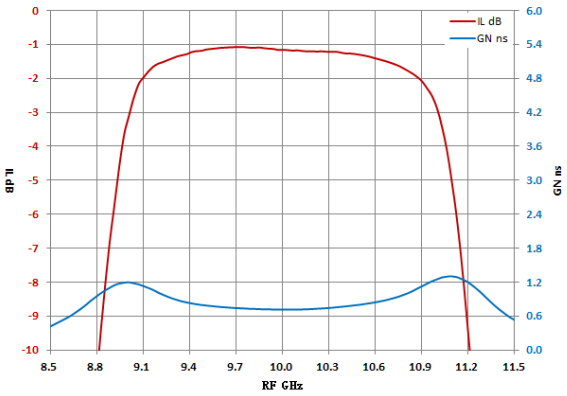
参考图

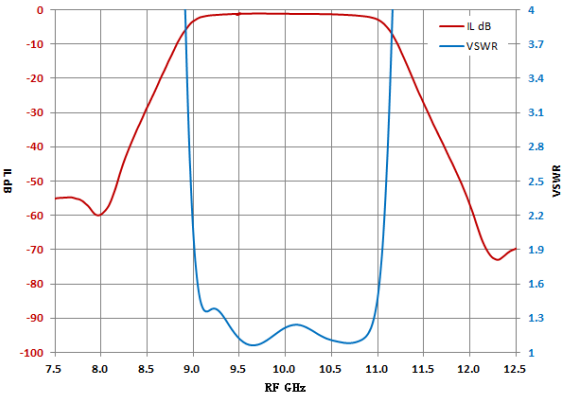


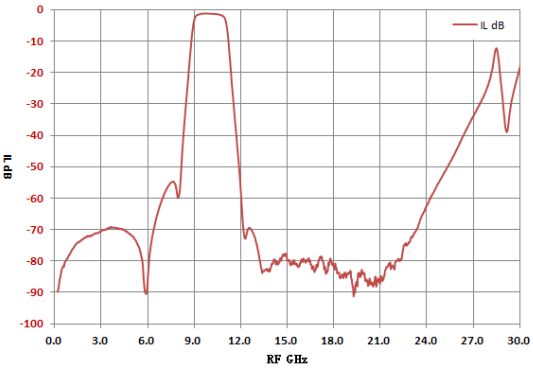
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



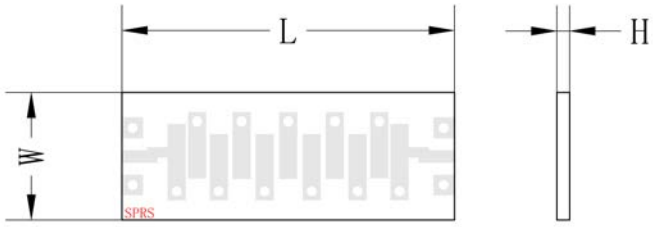
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.5	GHz
工作带宽	9.4-9.6	GHz
中心损耗	5.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-8.8GHz	dBc
带外抑制	40@10.2-23.0GHz	dBc

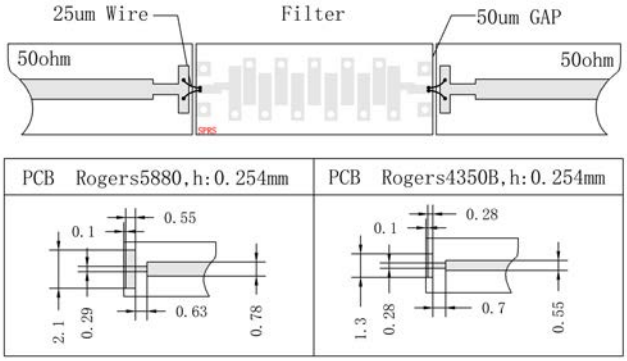
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



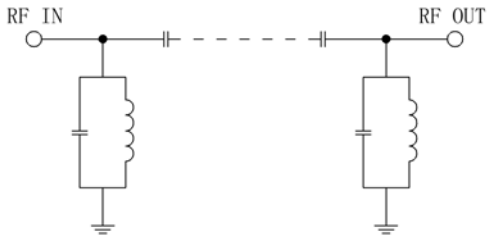
推荐装配图



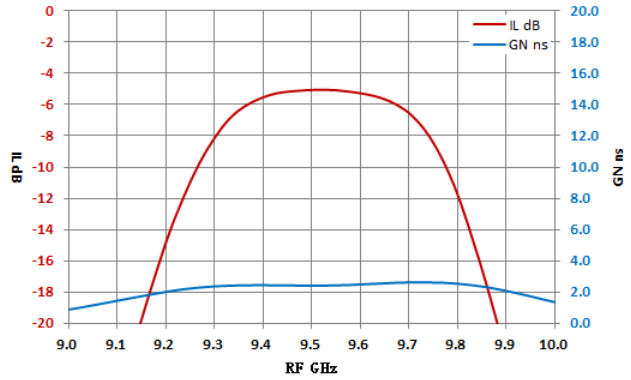
注意事项

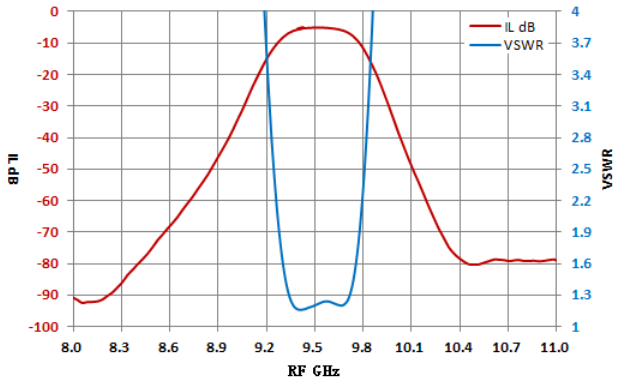
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

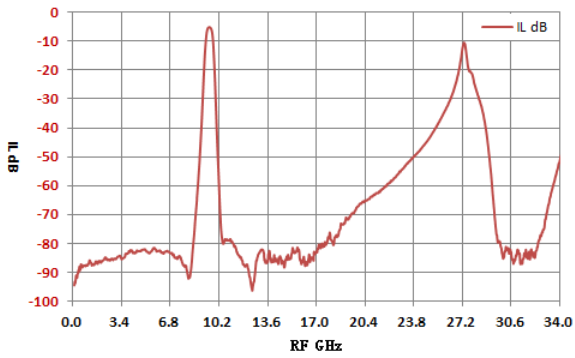
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



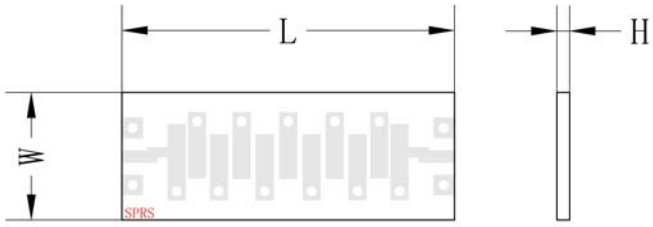
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	10.1	GHz
工作带宽	9.4-10.8	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	30@DC-8.5GHz	dBc
带外抑制	40@12.2-20.0GHz	dBc

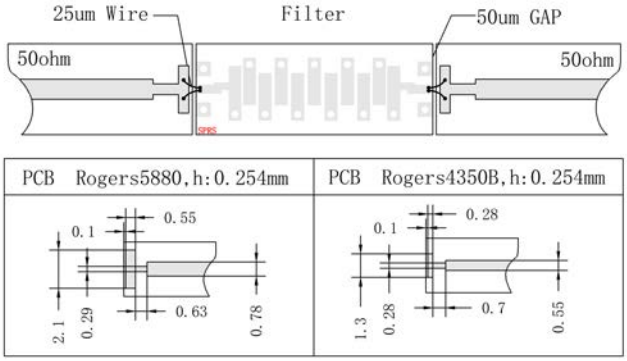
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：4.5，h：0.26

外形图：端口居中



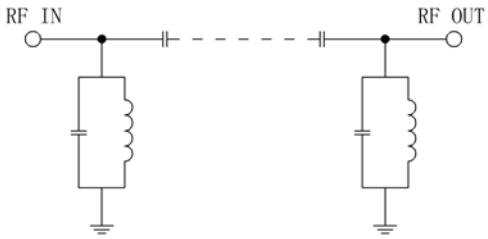
推荐装配图



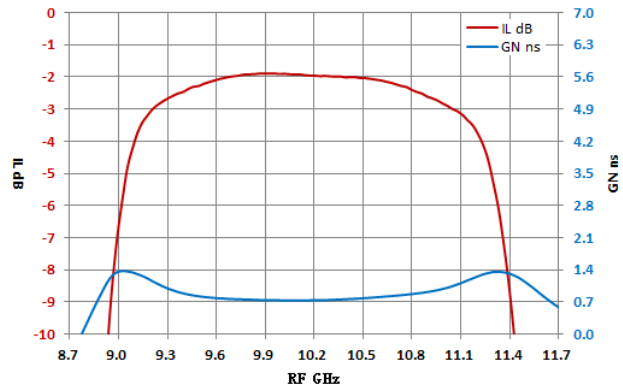
注意事项

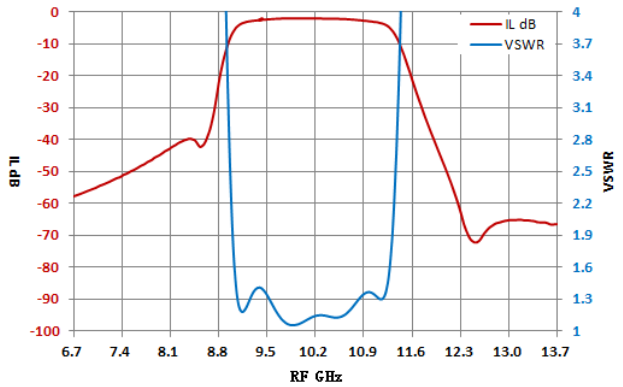
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

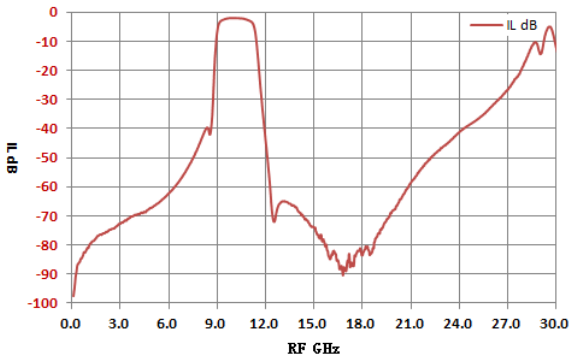
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

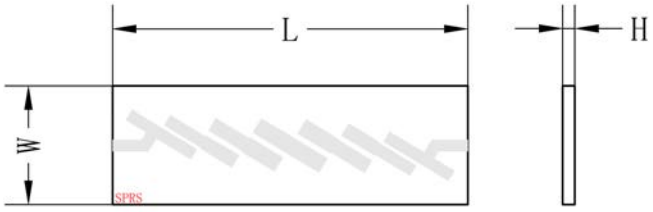
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	10.7	GHz
工作带宽	9.4-12.0	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-8.0GHz	dBc
带外抑制	40@13.7-24.0GHz	dBc

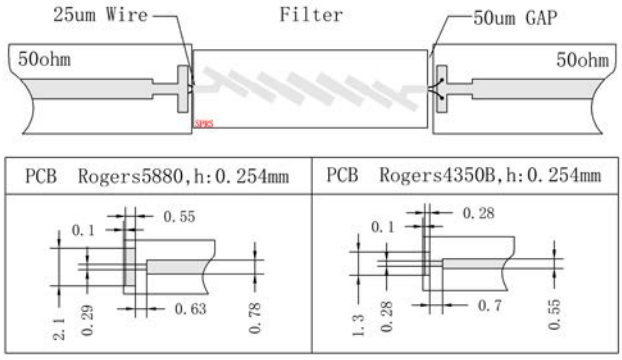
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



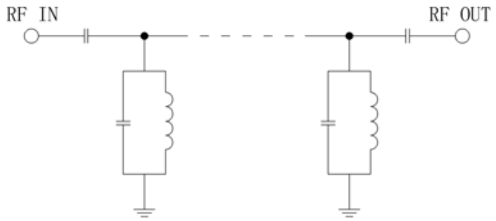
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

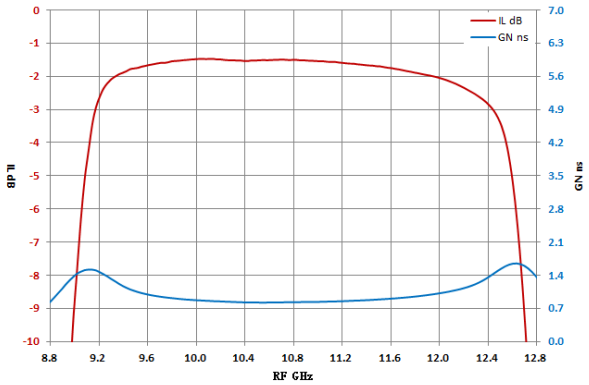
参考实物图

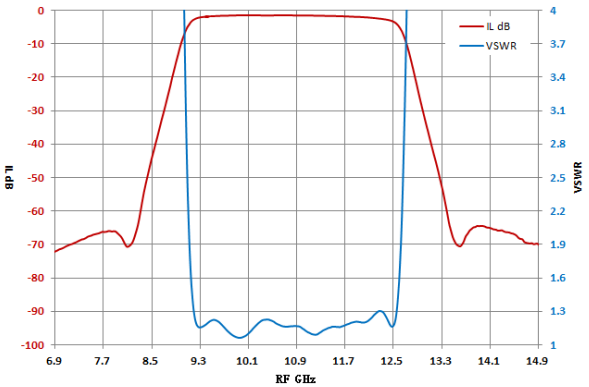


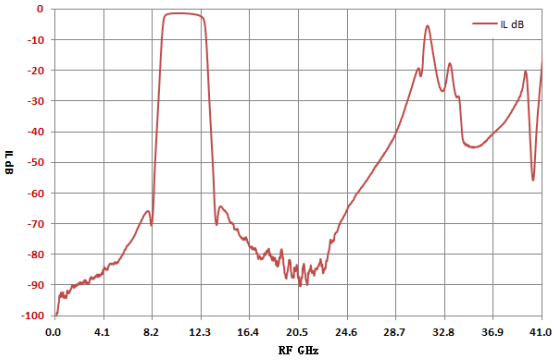
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



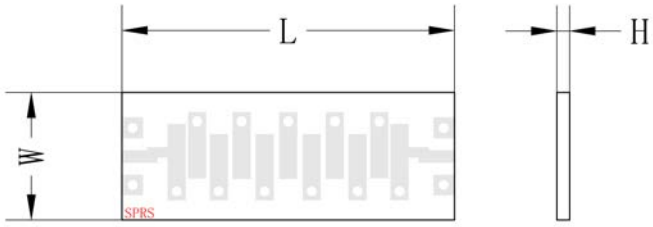
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	10.7	GHz
工作带宽	9.4-12.0	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-8.1GHz	dBc
带外抑制	40@13.5-28.0GHz	dBc

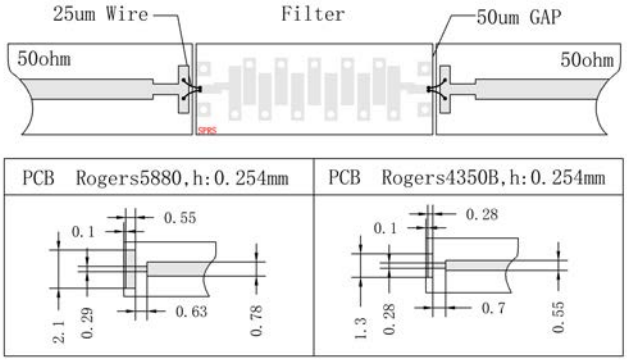
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



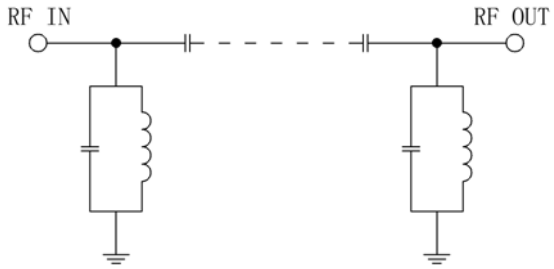
推荐装配图



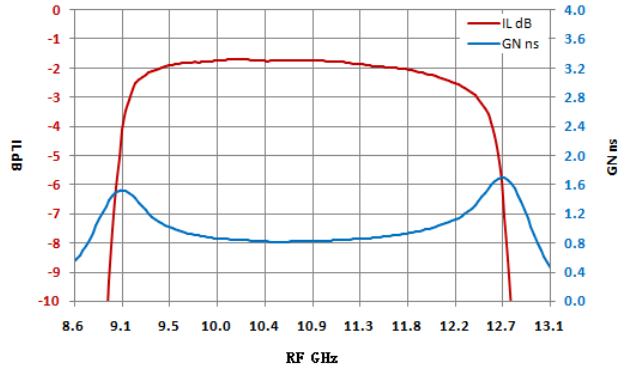
注意事项

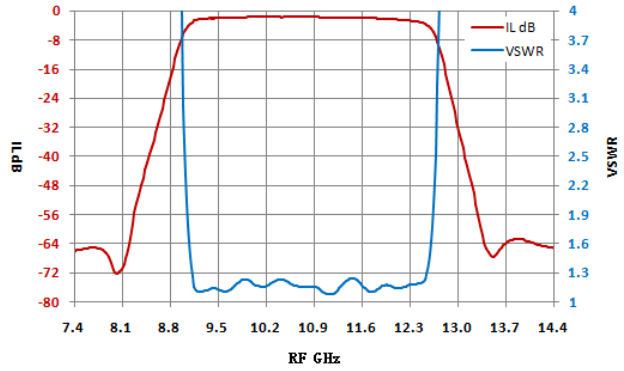
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

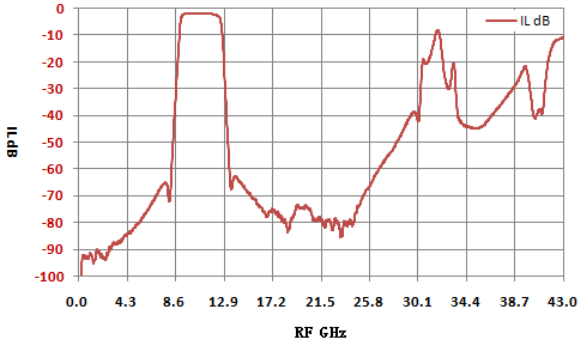
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



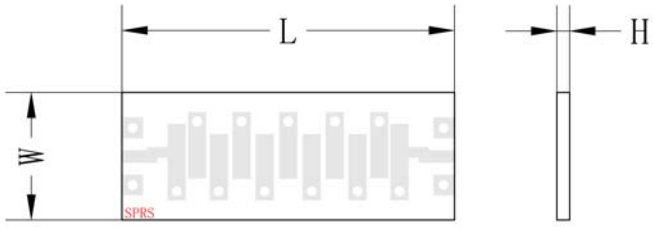
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.6	GHz
工作带宽	9.5-9.7	GHz
中心损耗	5.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-8.8GHz	dBc
带外抑制	40@10.3-25.0GHz	dBc

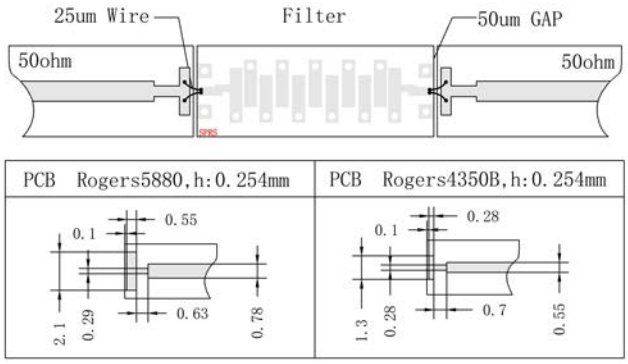
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.0，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



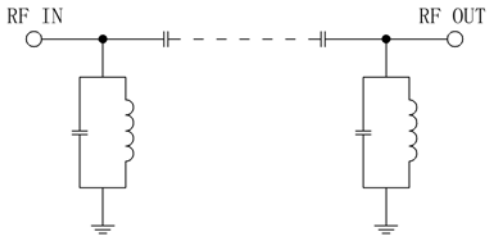
推荐装配图



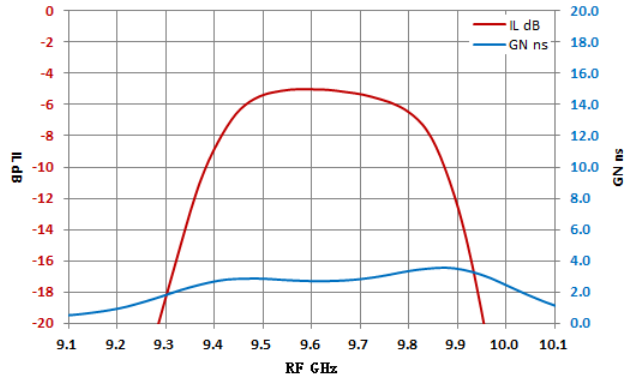
注意事项

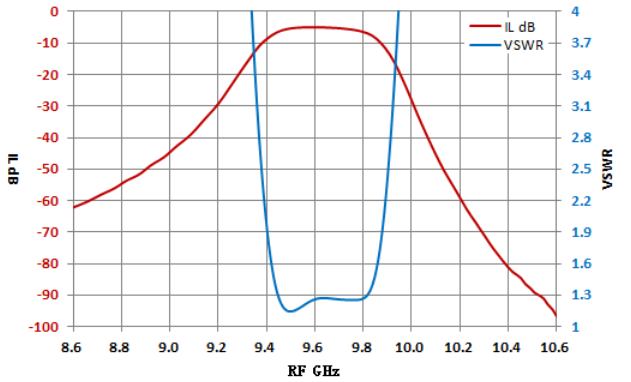
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

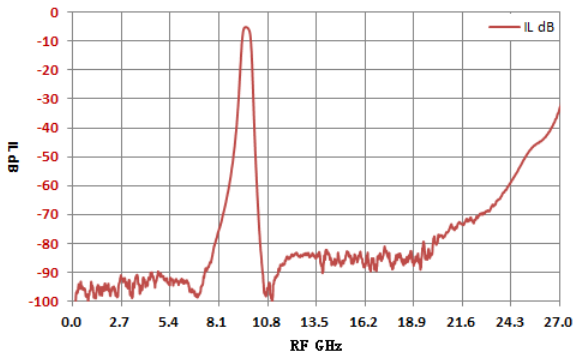
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



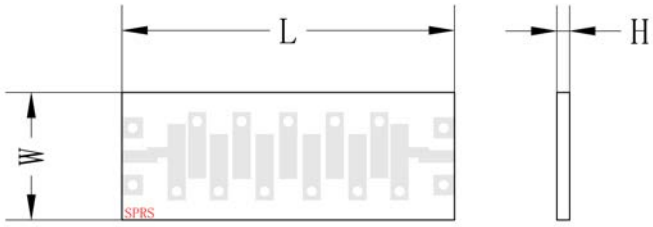
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	10.0	GHz
工作带宽	9.5-10.5	GHz
中心损耗	3.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-8.2GHz	dBc
带外抑制	40@11.8-25.0GHz	dBc

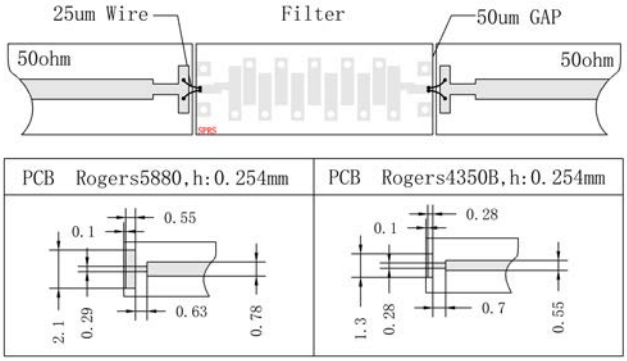
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.5，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



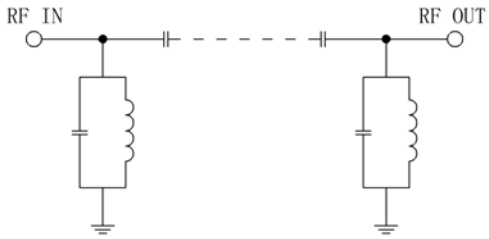
推荐装配图



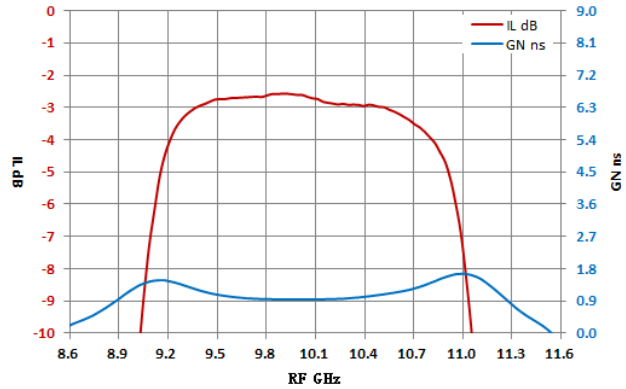
注意事项

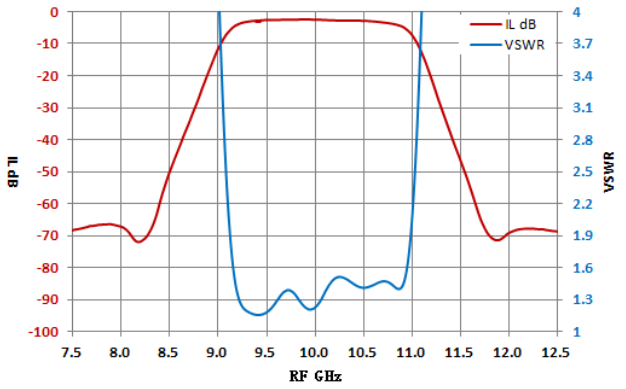
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

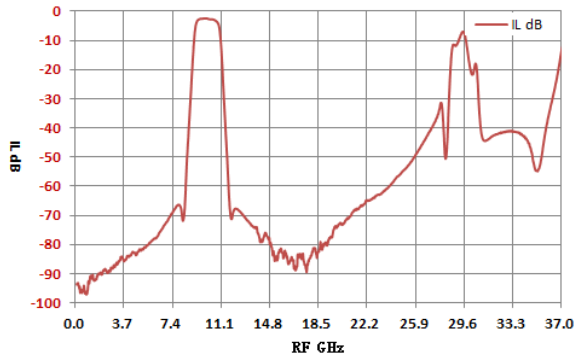
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



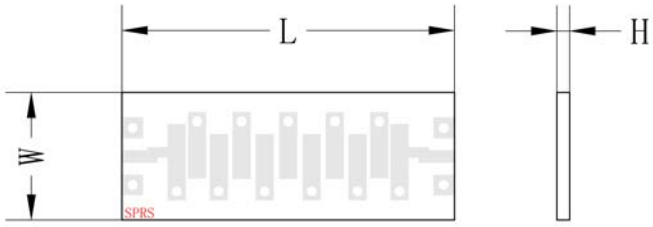
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	10.0	GHz
工作带宽	9.5-10.5	GHz
中心损耗	3.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	1.0	ns
带外抑制	35@DC-8.8GHz	dBc
带外抑制	35@11.4-24.0GHz	dBc

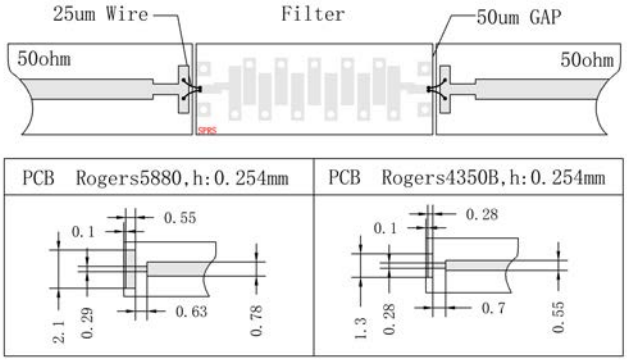
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



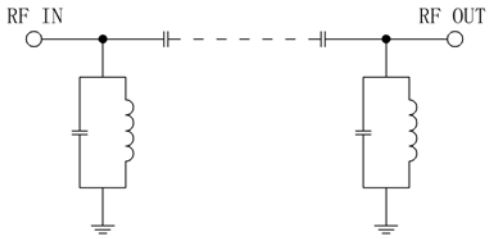
推荐装配图



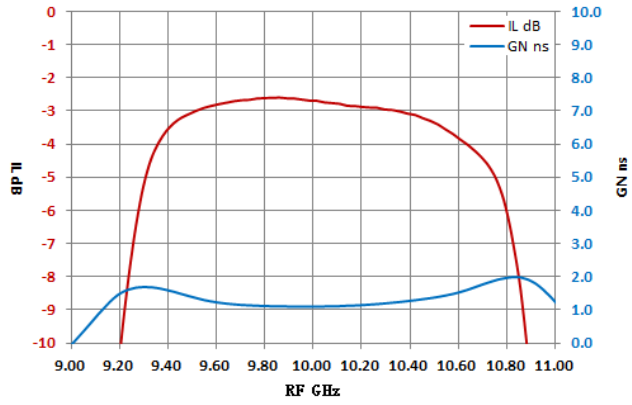
注意事项

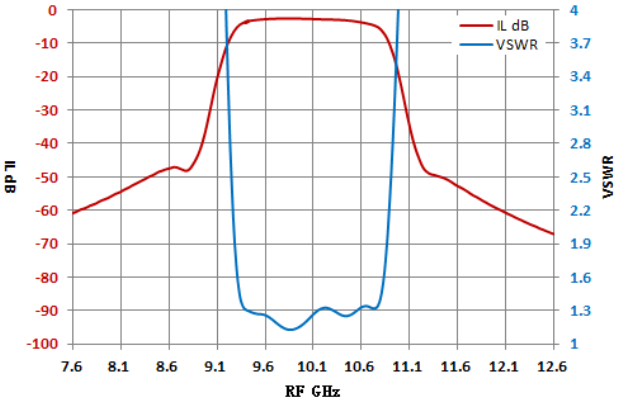
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

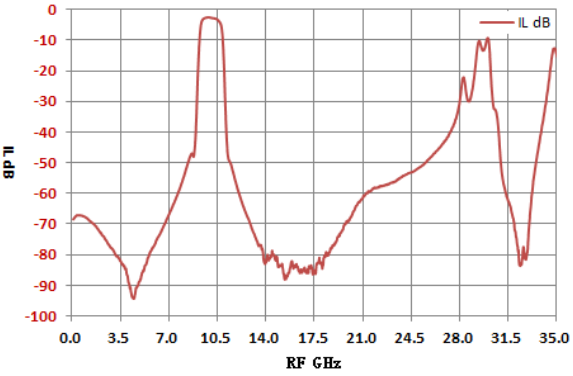
原理图



典型曲线







产品特点

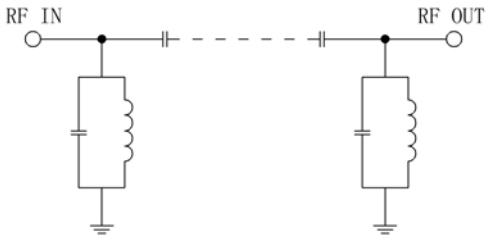
高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



技术要求

项目	参数	单位
中心频率	10.1	GHz
工作带宽	9.5-10.6	GHz
中心损耗	2.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	1.0	ns
带外抑制	35@DC-8.5GHz	dBc
带外抑制	40@11.8-23.0GHz	dBc

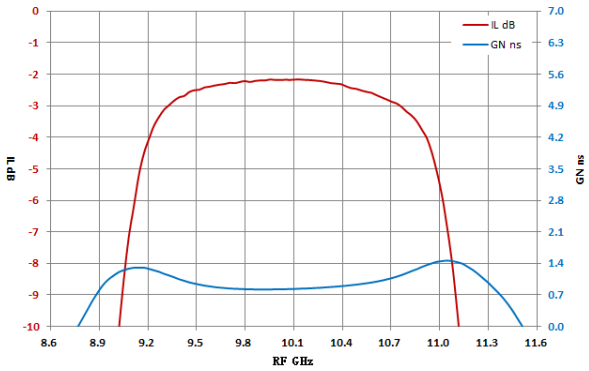
原理图

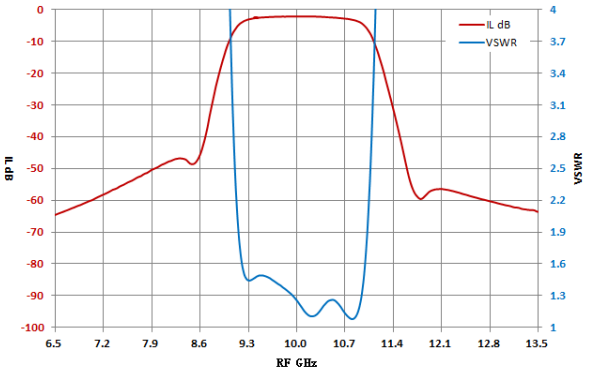


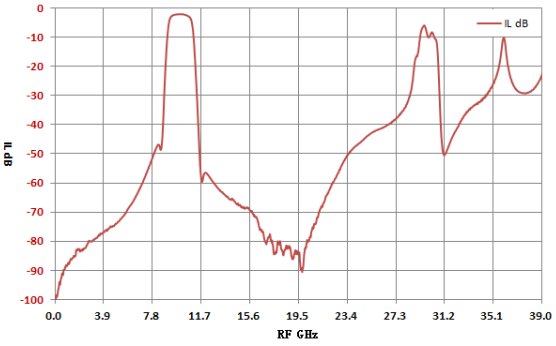
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：4.0，h：0.26

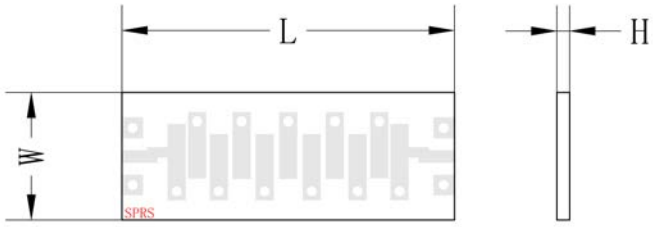
典型曲线



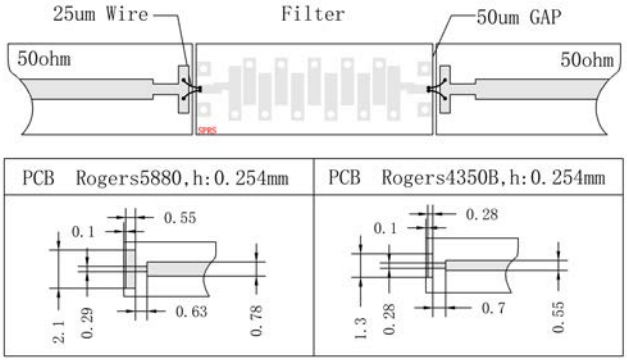




外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

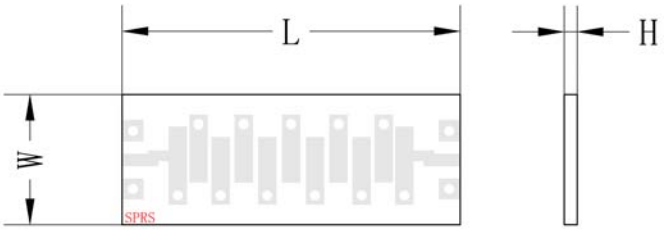
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	11.65	GHz
工作带宽	9.5-13.8	GHz
中心损耗	1.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	50@DC-6.4GHz	dBc
带外抑制	30@15.2-28.0GHz	dBc

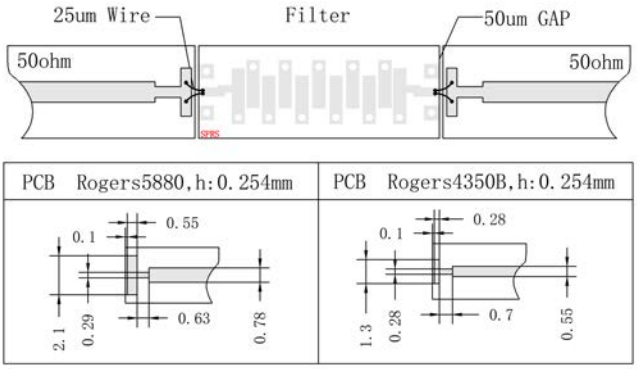
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：7.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

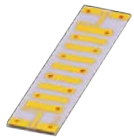
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

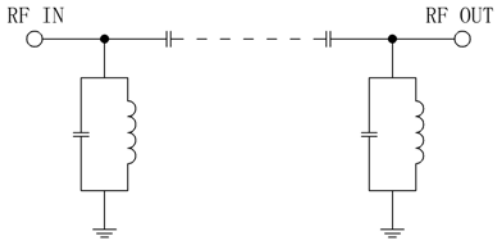
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

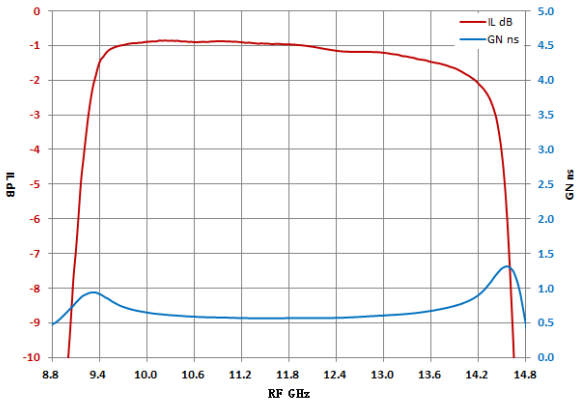
参考图

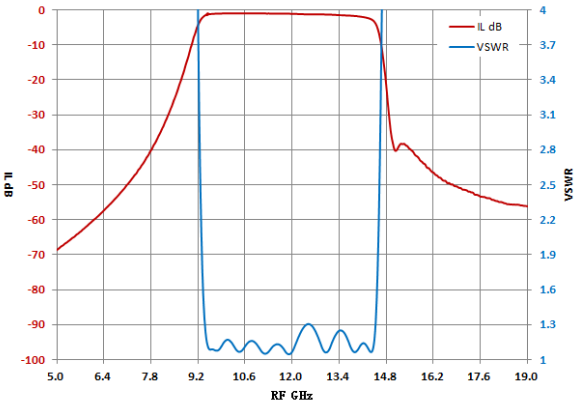


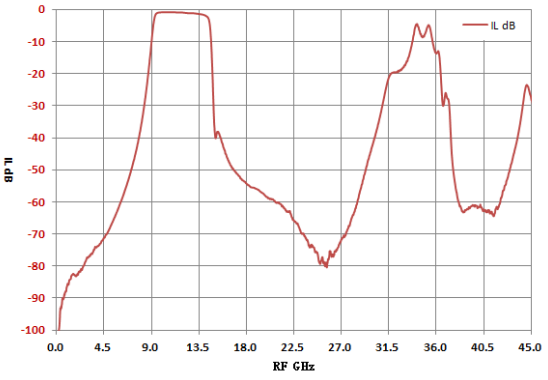
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



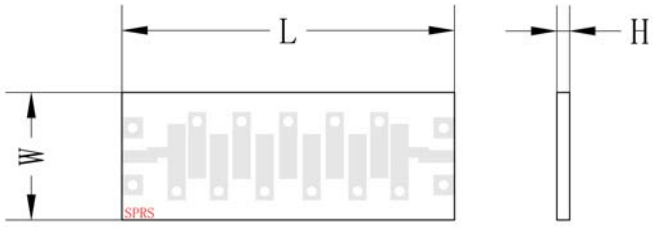
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	11.4	GHz
工作带宽	9.6-13.2	GHz
中心损耗	2.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-8.0GHz	dBc
带外抑制	40@15.6-27.0GHz	dBc

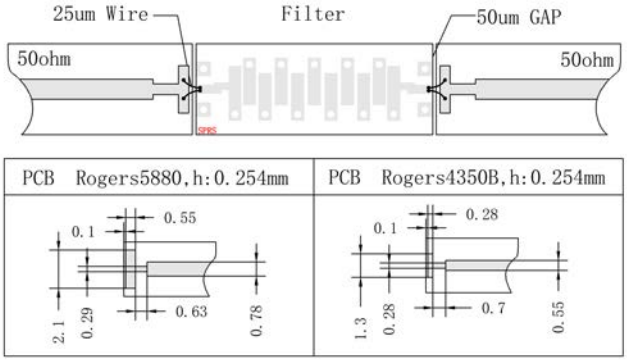
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.6，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



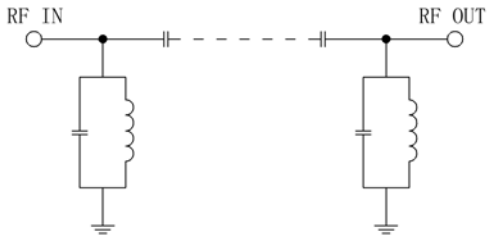
推荐装配图



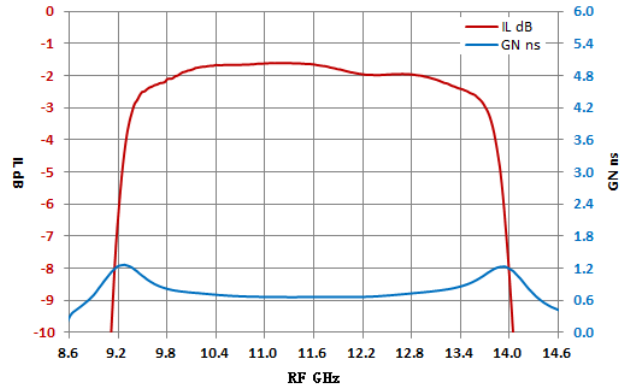
注意事项

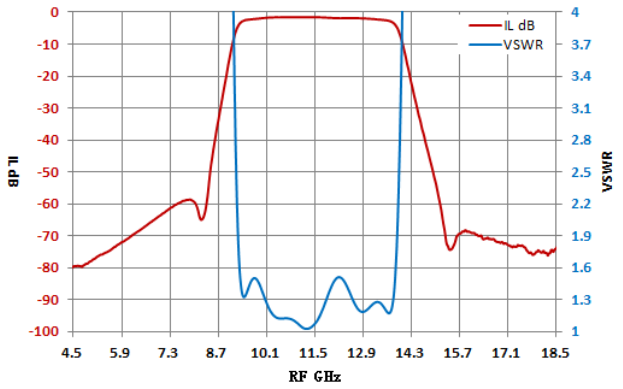
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

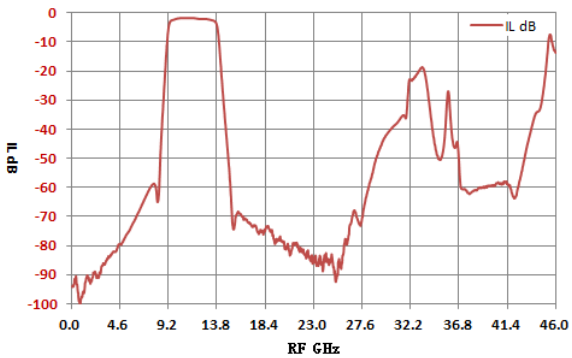
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

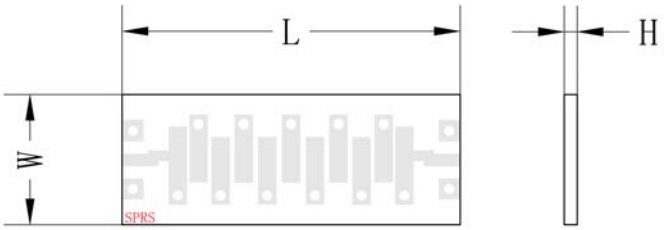
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	10.5	GHz
工作带宽	9.6-11.4	GHz
中心损耗	1.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-8.5GHz	dBc
带外抑制	40@12.7-27.0GHz	dBc

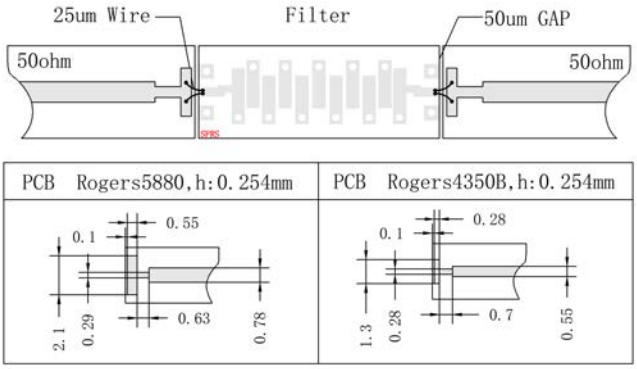
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

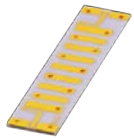
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

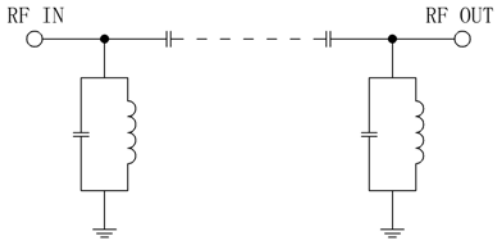
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

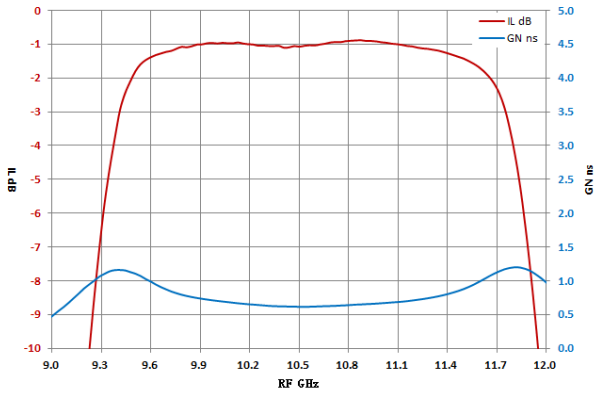
参考图

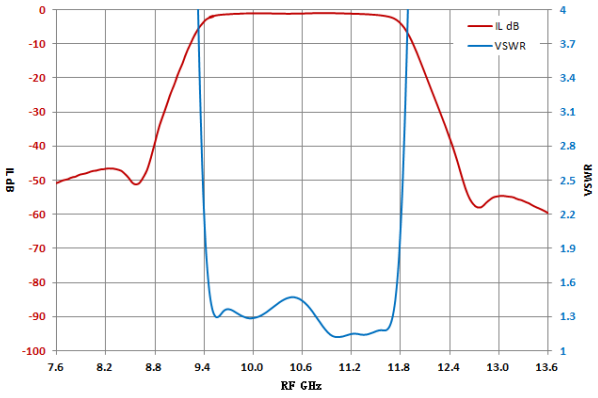


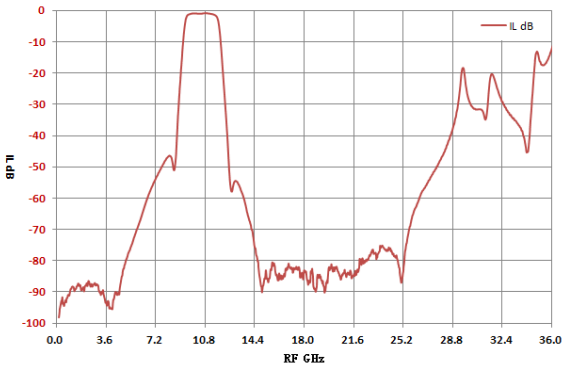
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



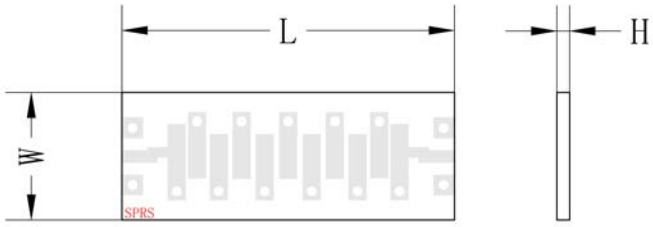
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	12.0	GHz
工作带宽	9.6-14.4	GHz
中心损耗	2.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-8.0GHz	dBc
带外抑制	40@16.6-29.0GHz	dBc

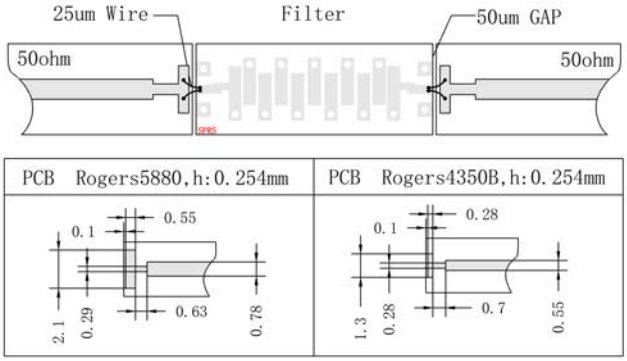
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



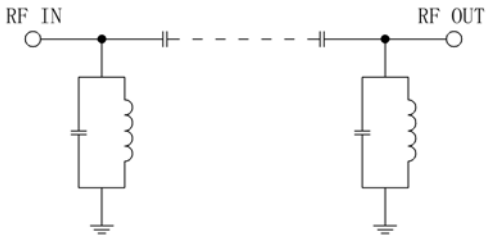
推荐装配图



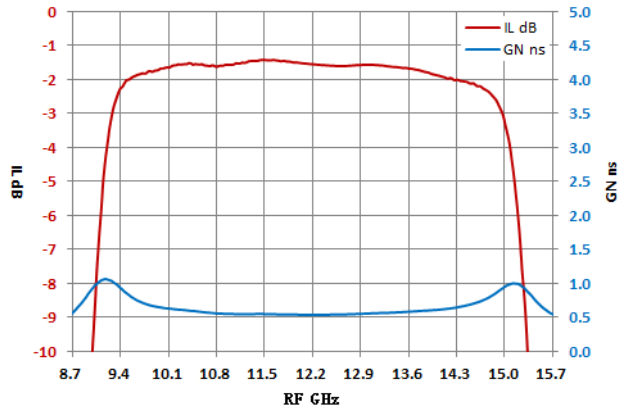
注意事项

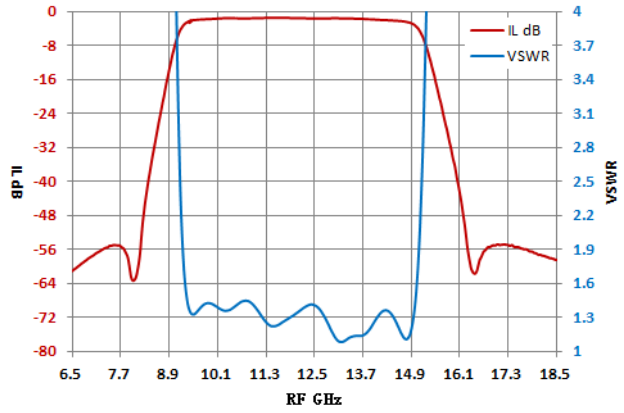
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

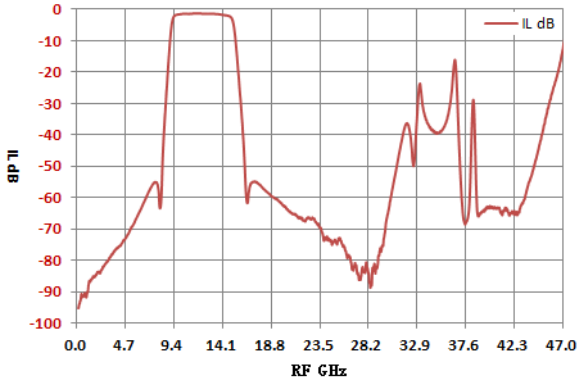
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



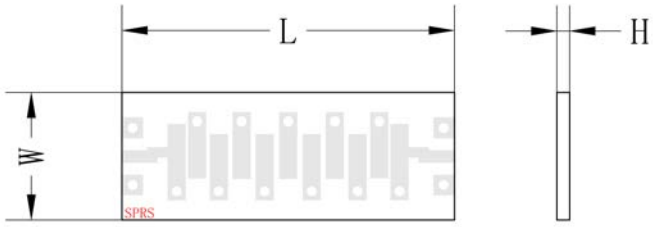
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	10.1	GHz
工作带宽	9.8-10.4	GHz
中心损耗	3.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	35@DC-9.0GHz	dBc
带外抑制	40@12.0-17.0GHz	dBc

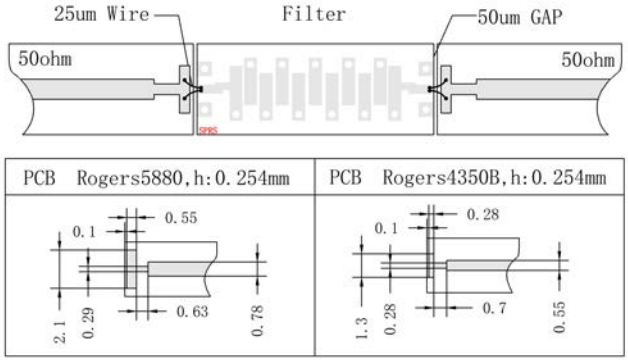
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：4.5，h：0.26

外形图：端口居中



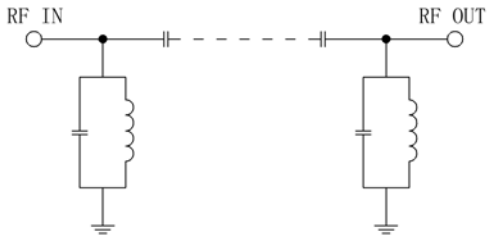
推荐装配图



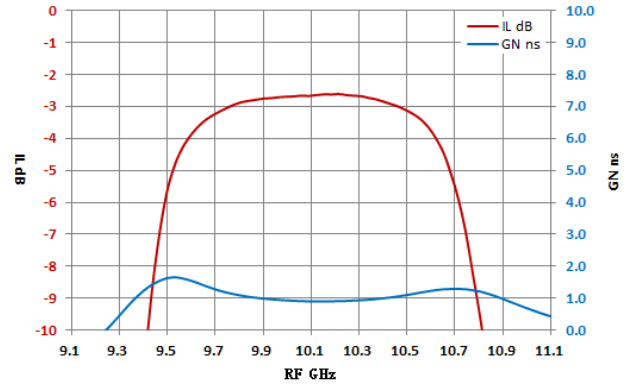
注意事项

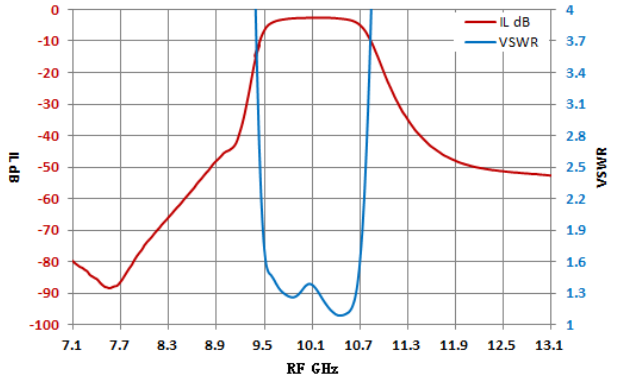
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

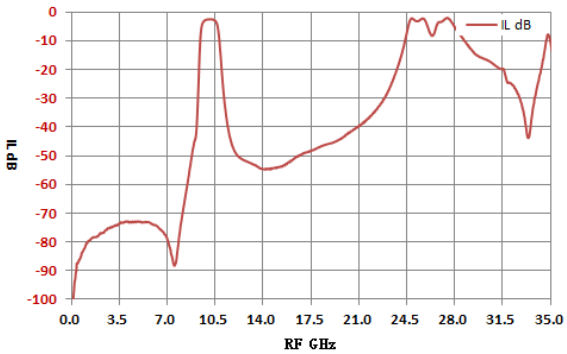
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



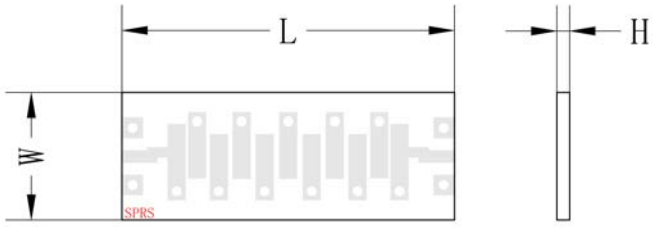
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	10.6	GHz
工作带宽	9.8-11.4	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	30@DC-8.9GHz	dBc
带外抑制	40@12.7-21.0GHz	dBc

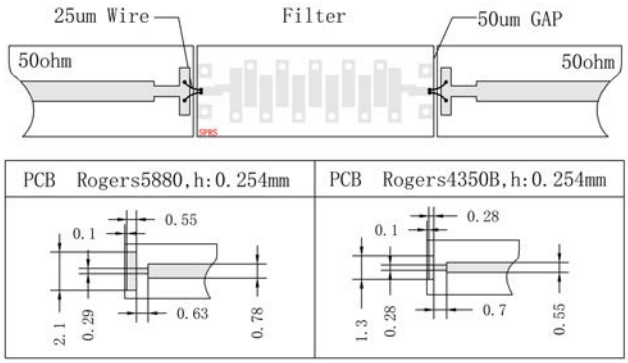
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：4.5，h：0.26

外形图：端口居中



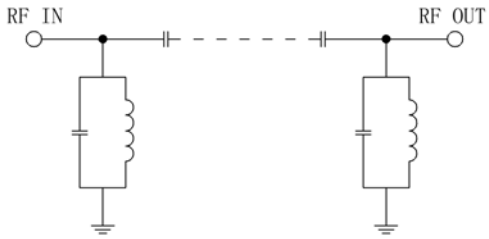
推荐装配图



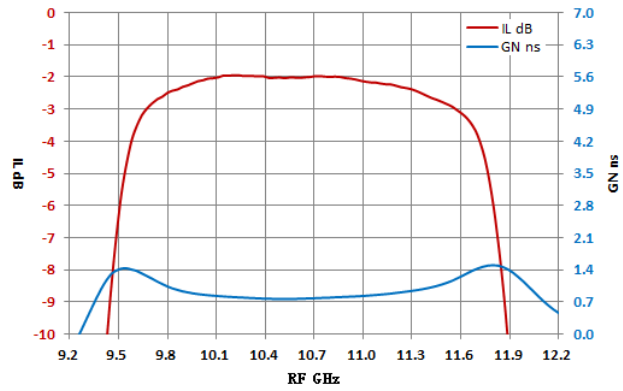
注意事项

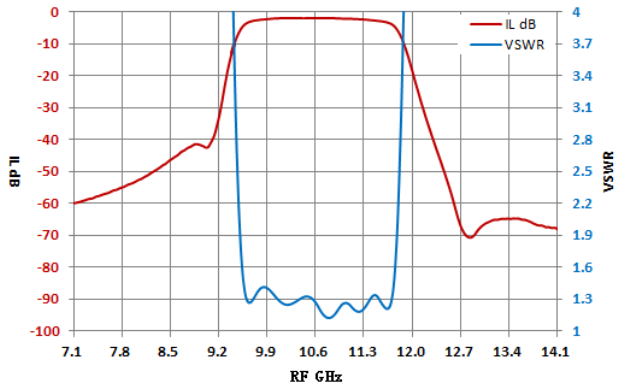
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

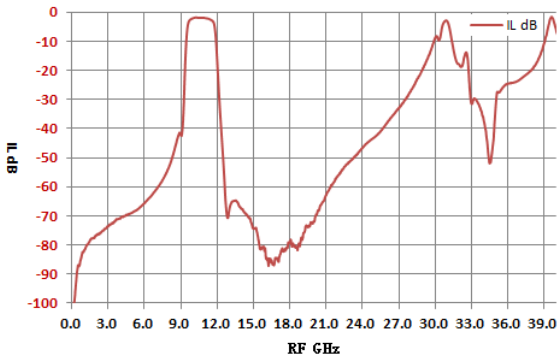
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

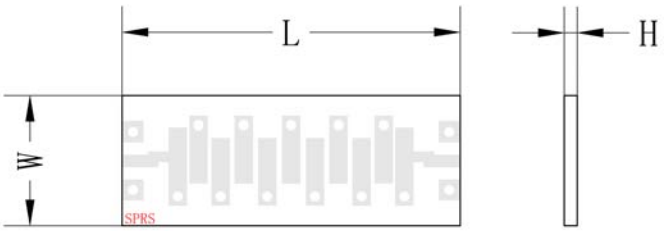
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	12.55	GHz
工作带宽	9.8-15.3	GHz
中心损耗	1.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.8:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	55@DC-7.3GHz	dBc
带外抑制	40@17.4-29.0GHz	dBc

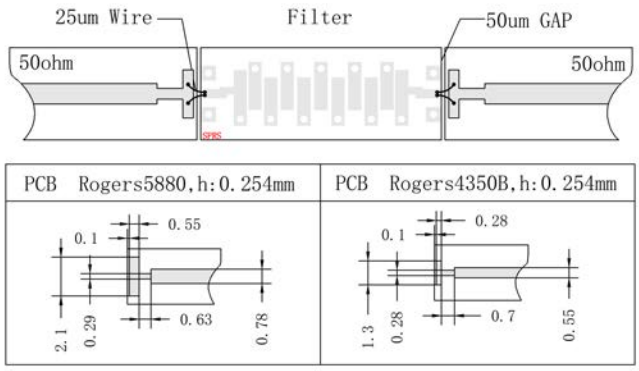
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：6.0，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

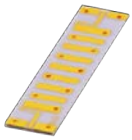
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

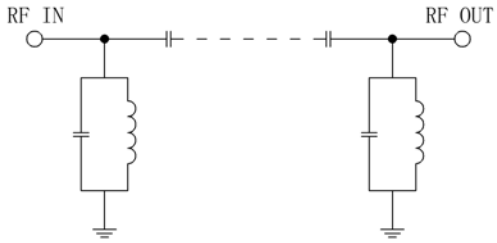
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

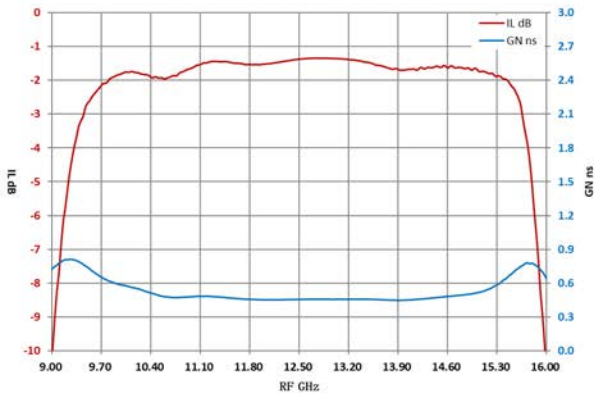
参考图

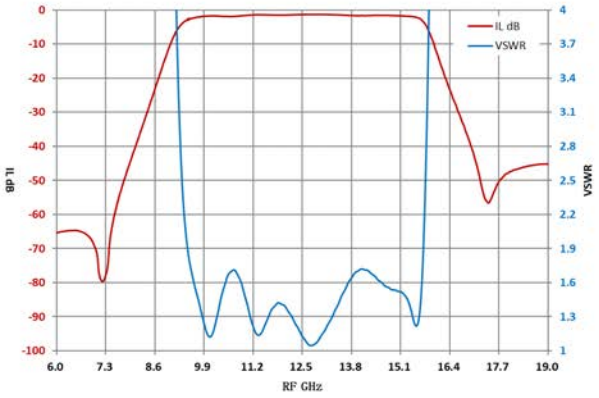


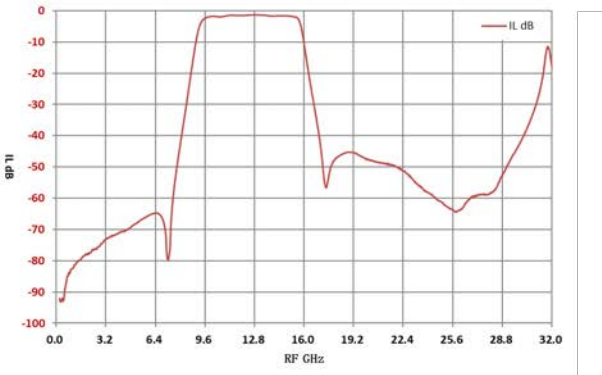
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

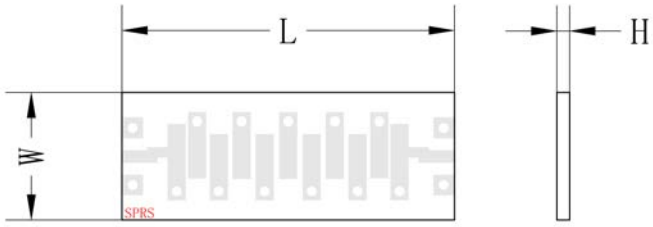
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	10	GHz
工作带宽	9.9-10.1	GHz
中心损耗	4.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-9.4GHz	dBc
带外抑制	40@10.6-24.5.0GHz	dBc

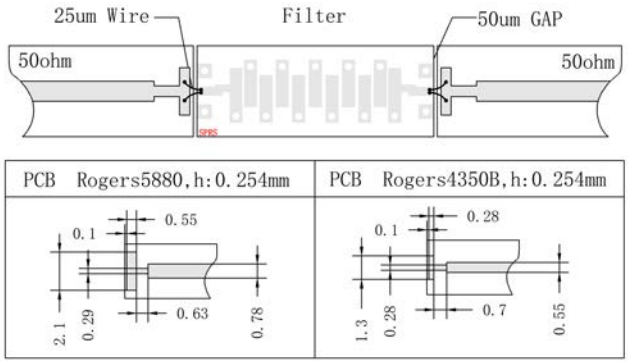
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.5，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



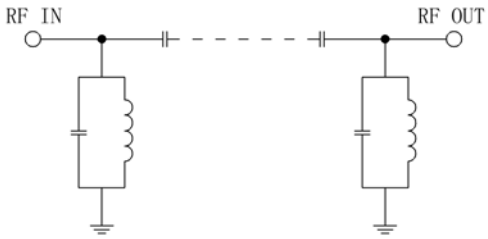
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

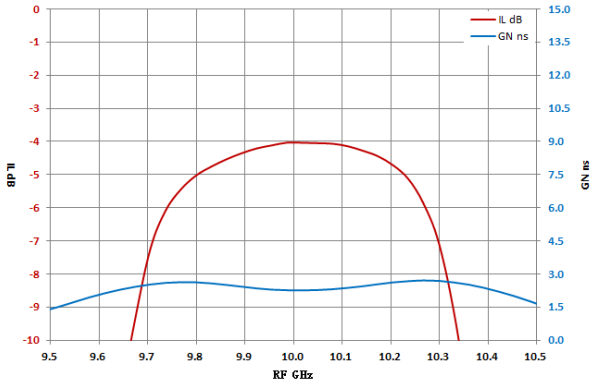
参考实物图

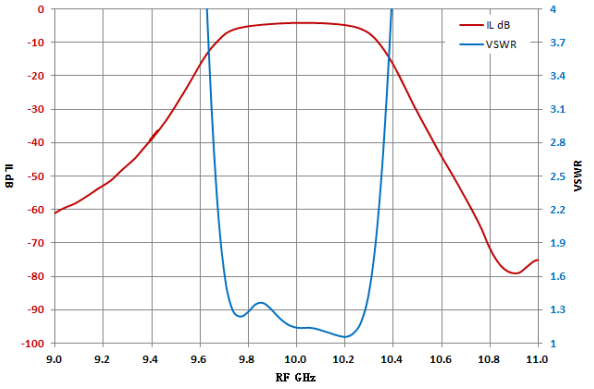


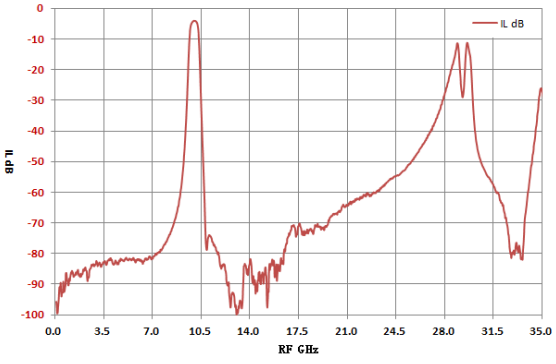
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



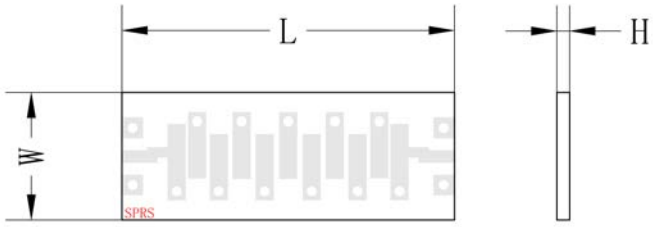
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	10.7	GHz
工作带宽	9.9-11.4	GHz
中心损耗	3.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-8.8GHz	dBc
带外抑制	40@12.6-26.0GHz	dBc

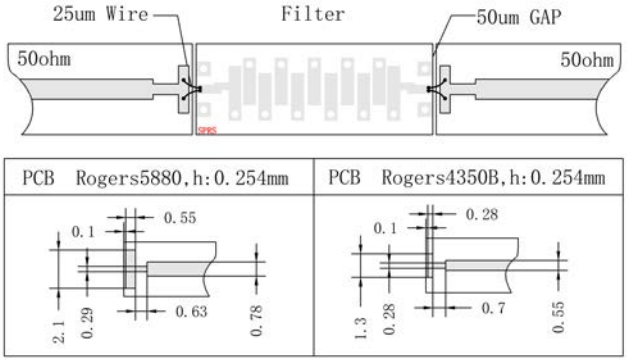
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：10，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



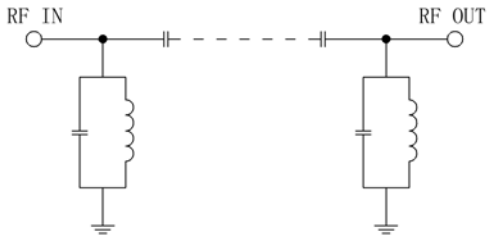
推荐装配图



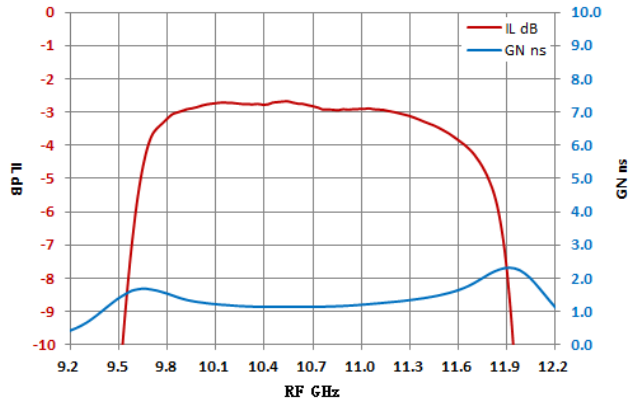
注意事项

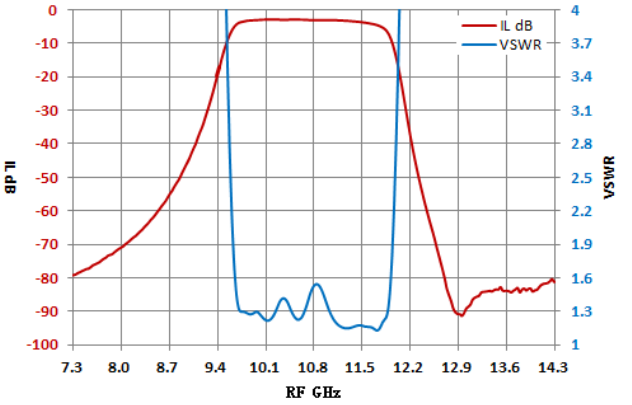
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

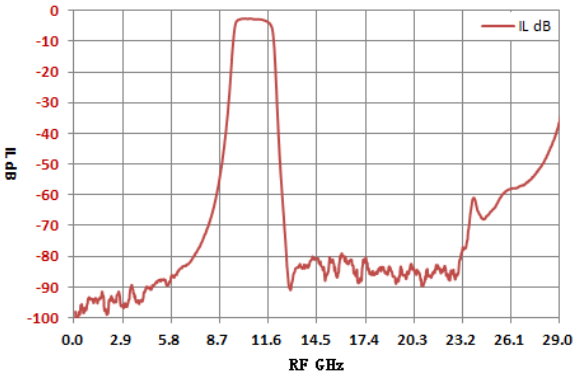
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

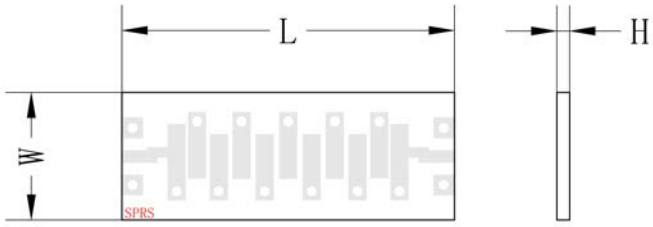
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	10.05	GHz
工作带宽	10.0-10.1	GHz
中心损耗	5.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	1.0	ns
带外抑制	40@DC-9.1GHz	dBc
带外抑制	40@10.9-25.0GHz	dBc

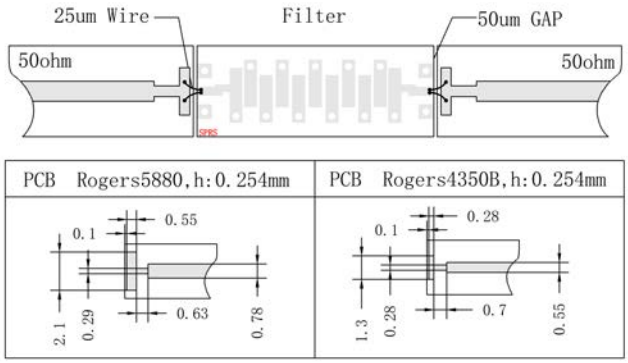
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.5，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



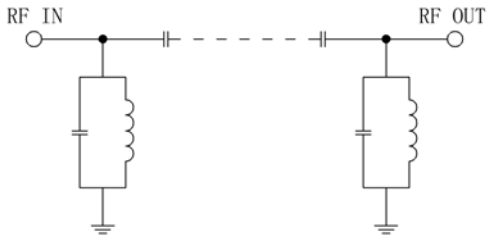
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

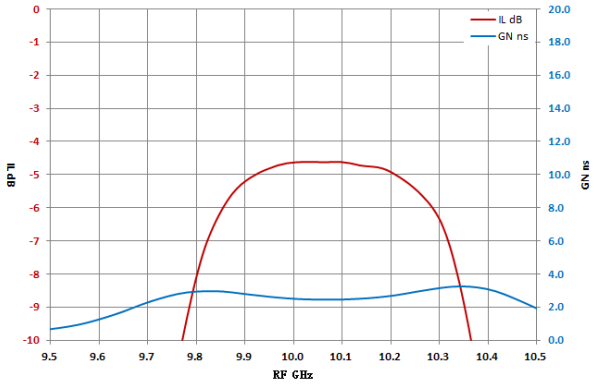
参考实物图

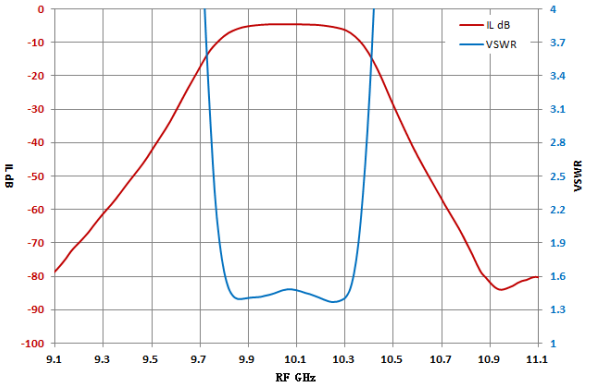


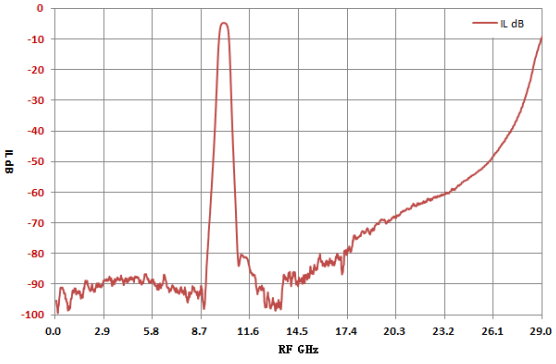
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

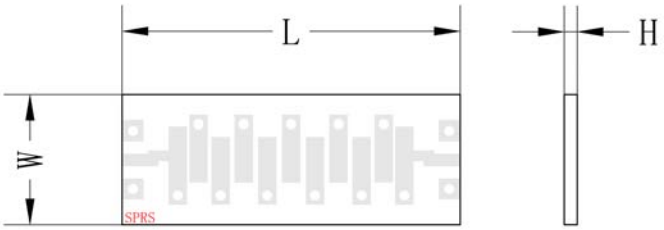
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	10.5	GHz
工作带宽	10.0-11.0	GHz
中心损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-8.8GHz	dBc
带外抑制	35@11.8-26.0GHz	dBc

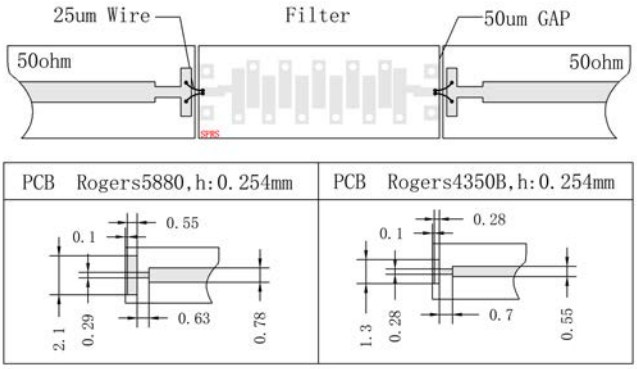
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：9.0，W：3.0，h：0.39

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.61mm,端口可互换;

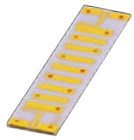
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

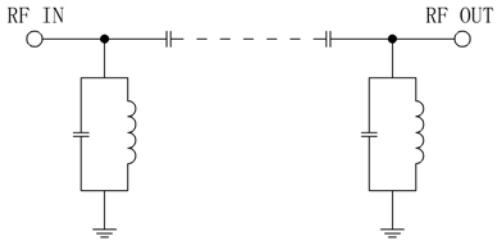
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

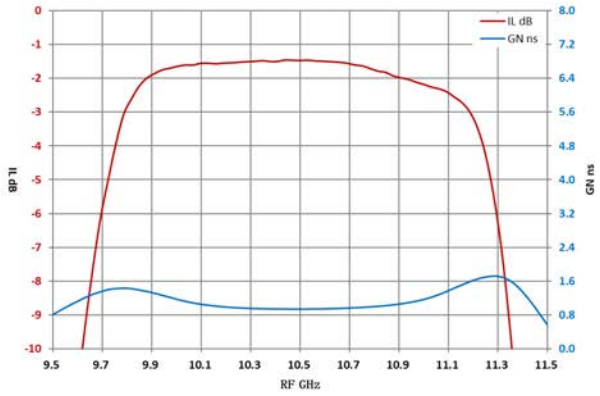
参考图

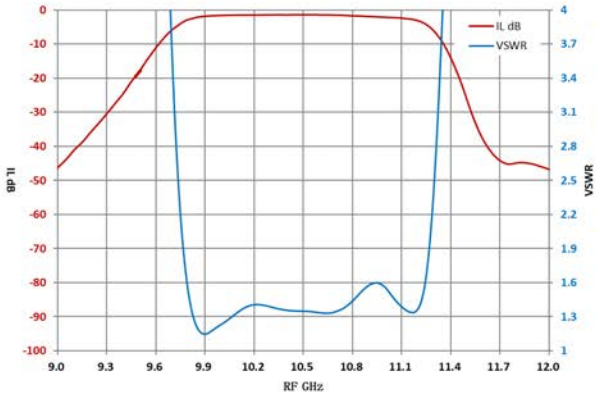


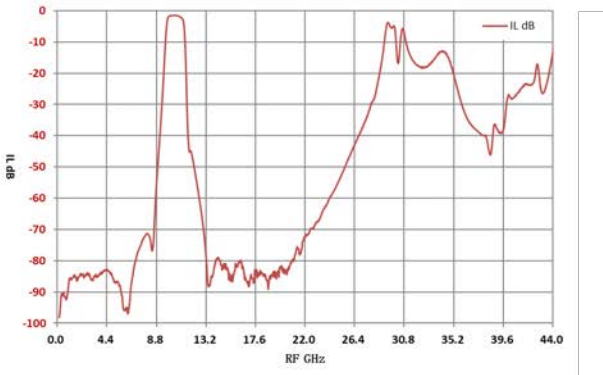
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



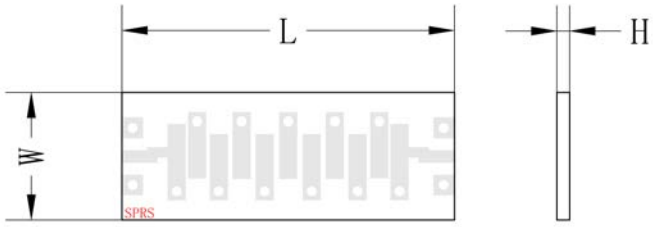
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	10.9	GHz
工作带宽	10.0-11.8	GHz
中心损耗	2.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-8.9GHz	dBc
带外抑制	30@12.9-25.0GHz	dBc

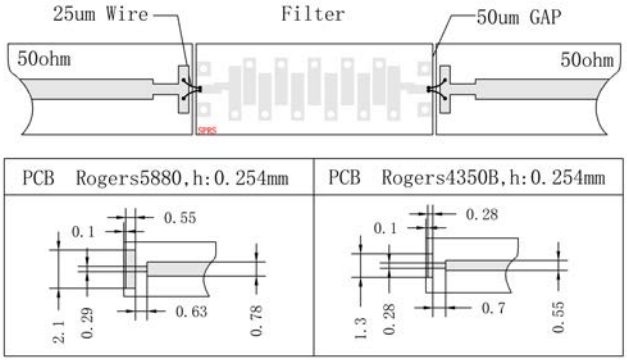
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



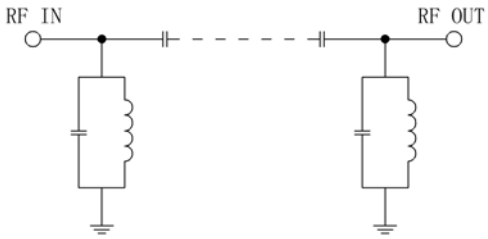
推荐装配图



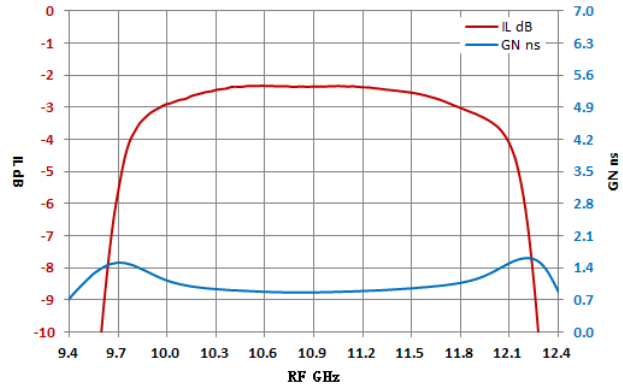
注意事项

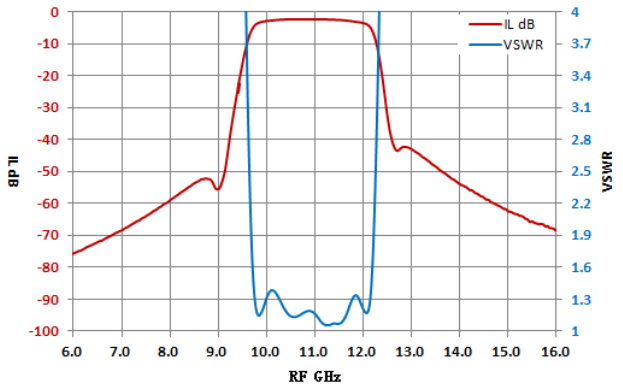
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

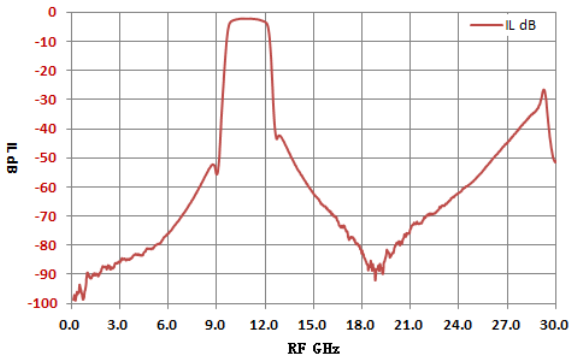
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



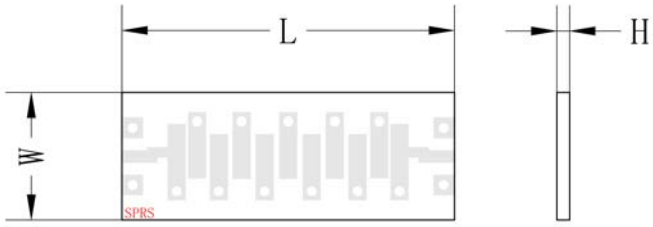
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	11.0	GHz
工作带宽	10.0-12.0	GHz
中心损耗	2.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-8.7GHz	dBc
带外抑制	40@13.3-27.0GHz	dBc

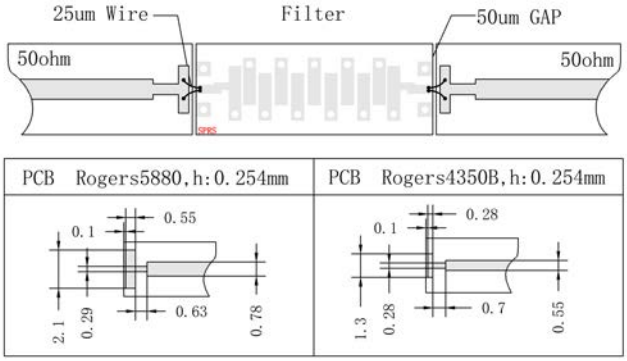
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.0，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



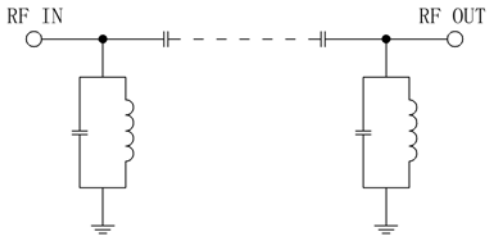
推荐装配图



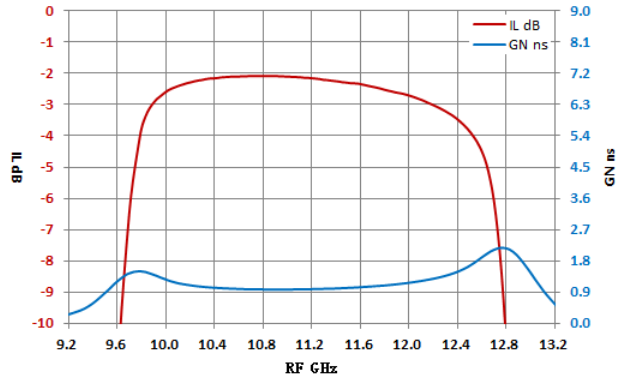
注意事项

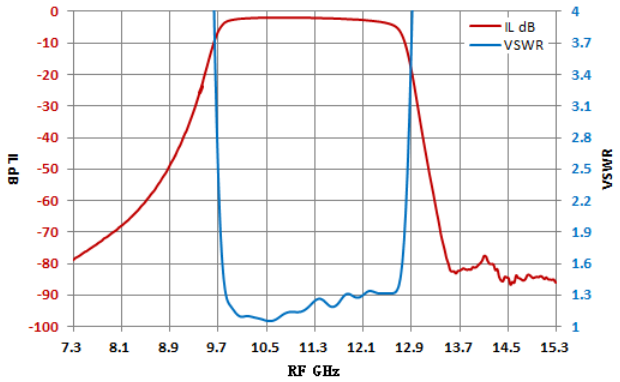
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

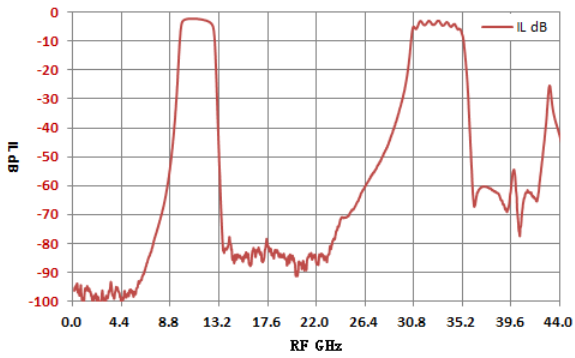
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



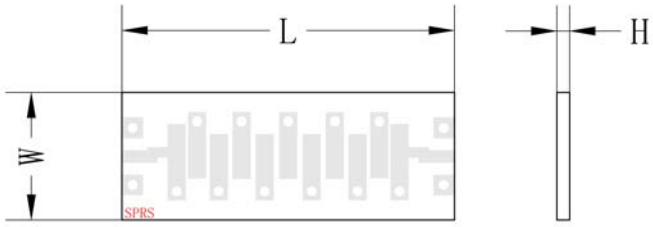
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	11.5	GHz
工作带宽	10.0-13.0	GHz
中心损耗	2.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-8.7GHz	dBc
带外抑制	40@14.6-27.0GHz	dBc

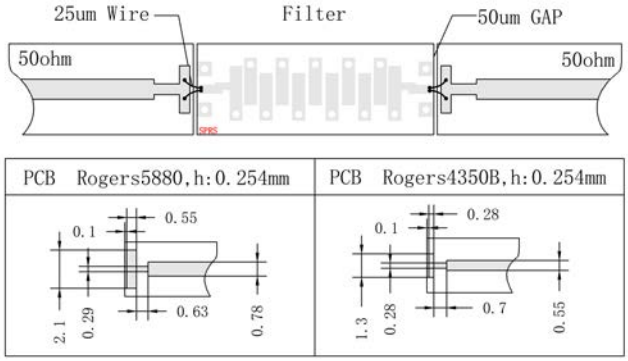
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



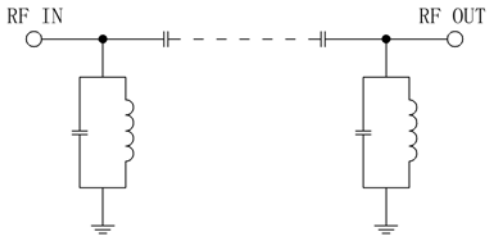
推荐装配图



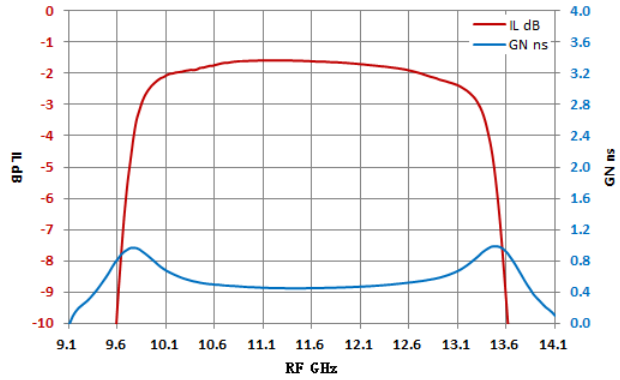
注意事项

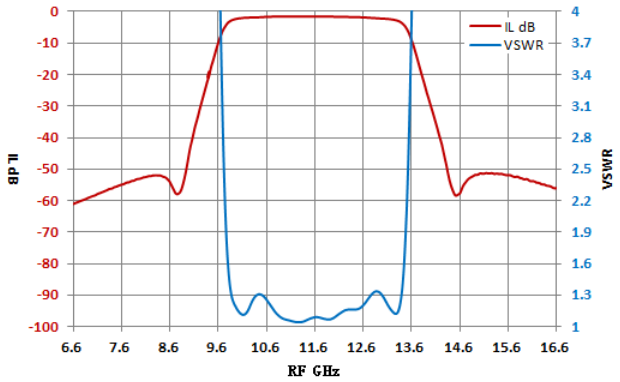
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

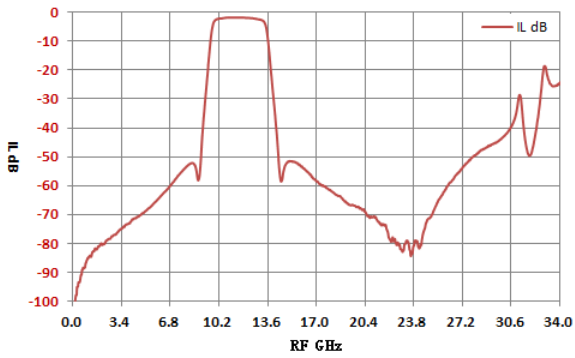
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



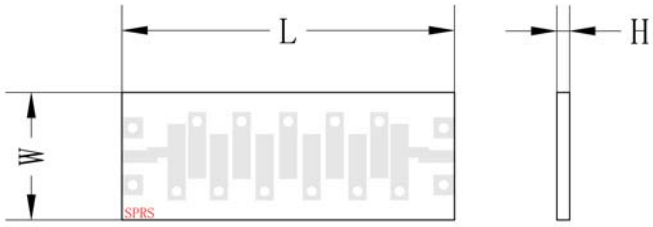
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	12.0	GHz
工作带宽	10.0-14.0	GHz
中心损耗	1.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-8.5GHz	dBc
带外抑制	40@16.2-28.0GHz	dBc

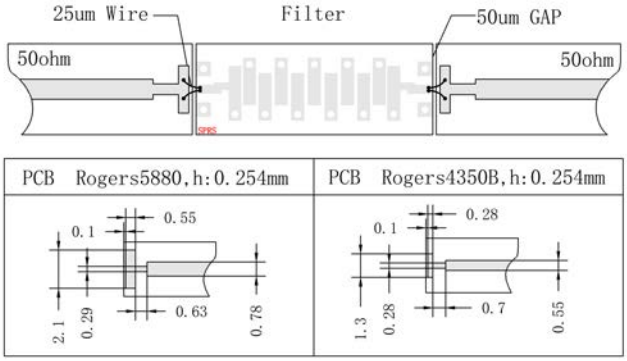
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



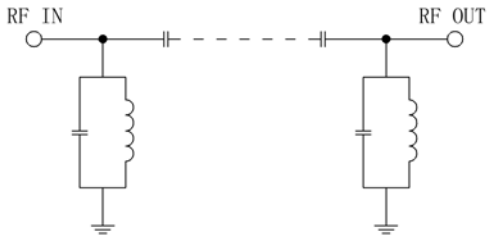
推荐装配图



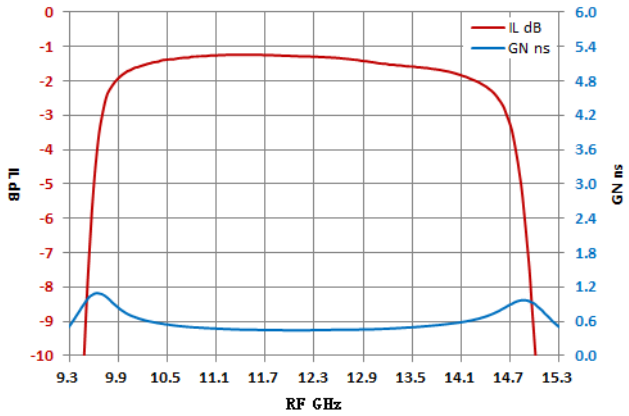
注意事项

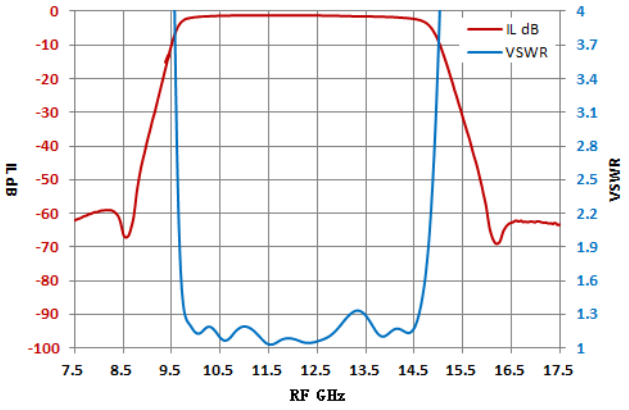
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

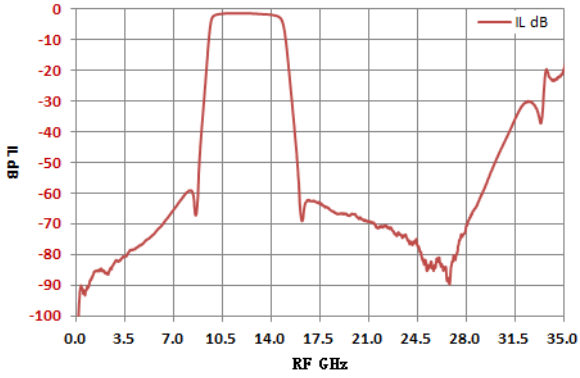
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



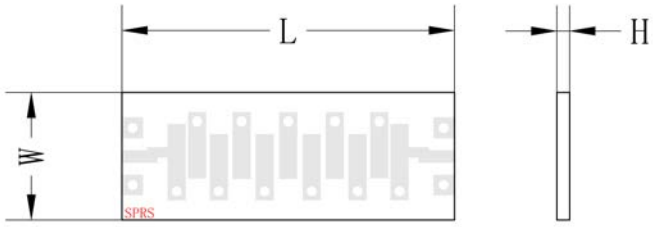
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	12.5	GHz
工作带宽	10.0-15.0	GHz
中心损耗	2.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-6.8GHz	dBc
带外抑制	40@17.3-29.0GHz	dBc

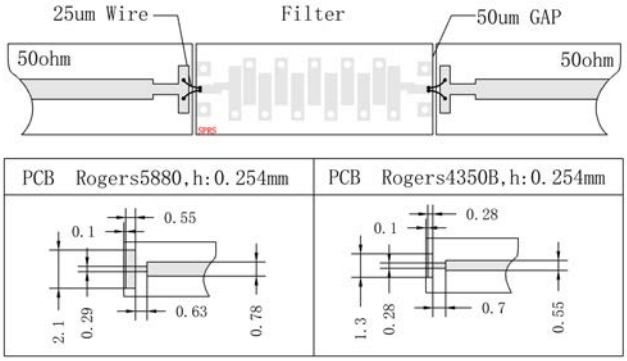
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



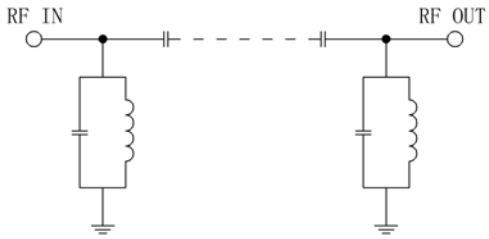
推荐装配图



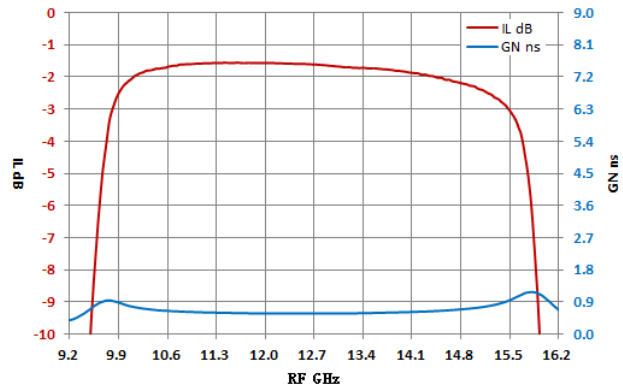
注意事项

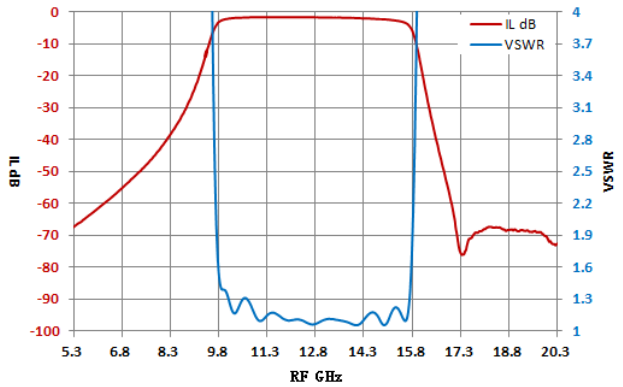
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

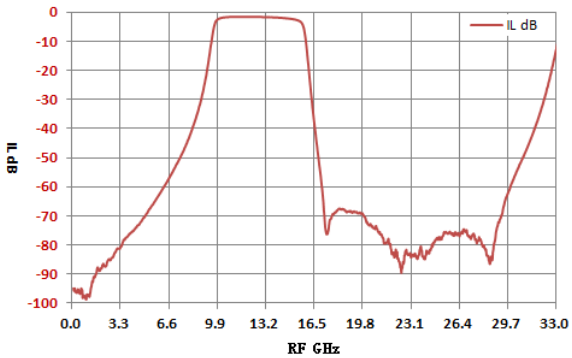
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



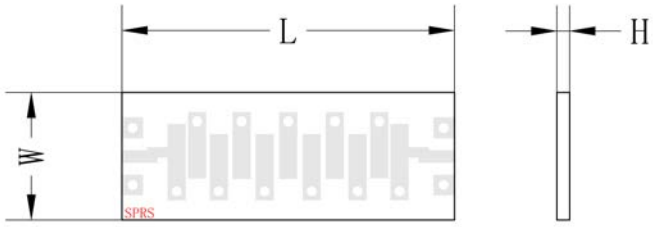
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	14.0	GHz
工作带宽	10.0-18.0	GHz
中心损耗	1.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-6.2GHz	dBc
带外抑制	30@20.2-33.0GHz	dBc

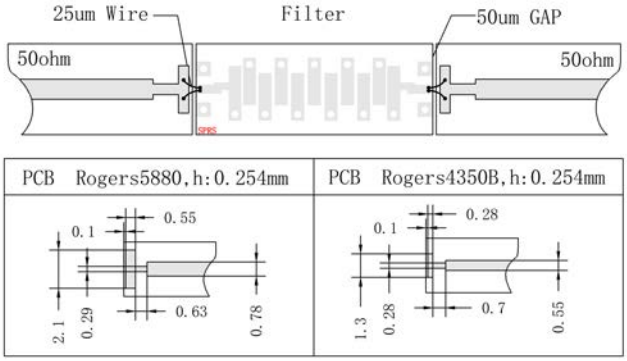
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



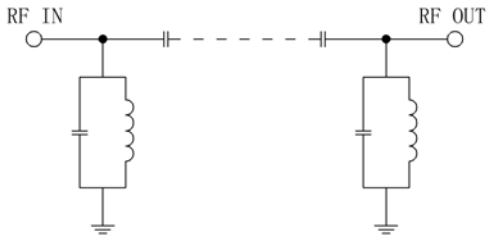
推荐装配图



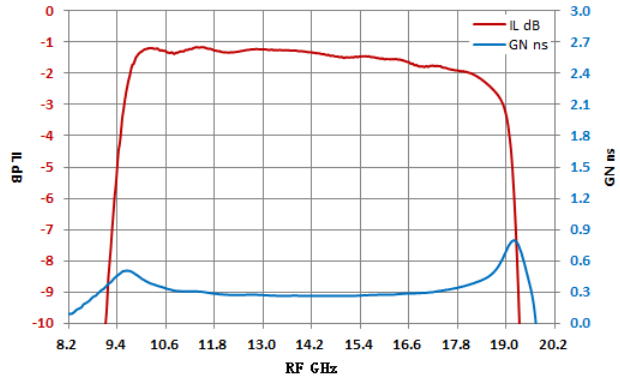
注意事项

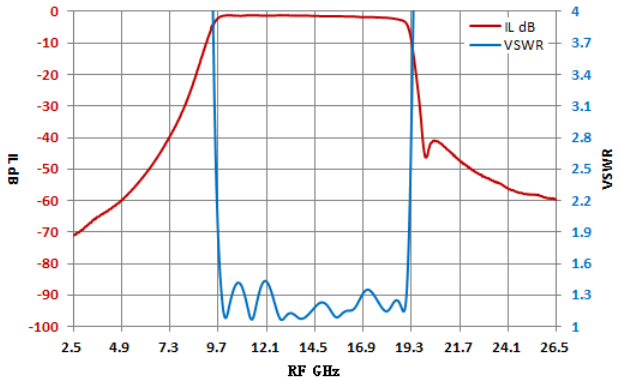
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

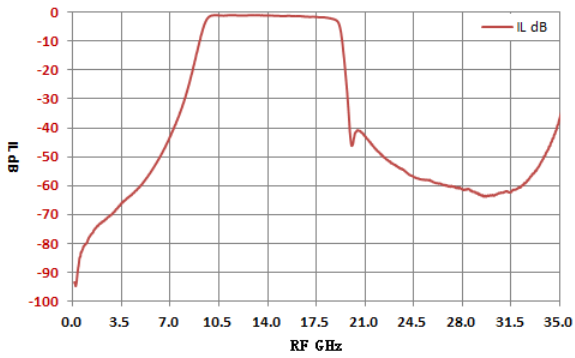
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



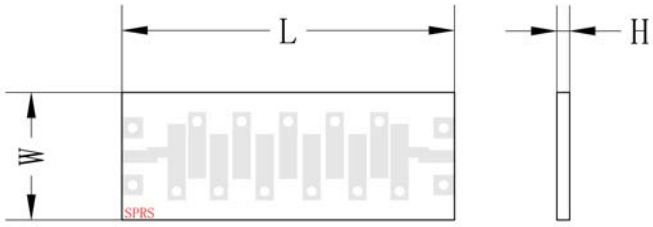
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	11.8	GHz
工作带宽	10.1-13.4	GHz
中心损耗	1.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-8.8GHz	dBc
带外抑制	40@15.3-28.0GHz	dBc

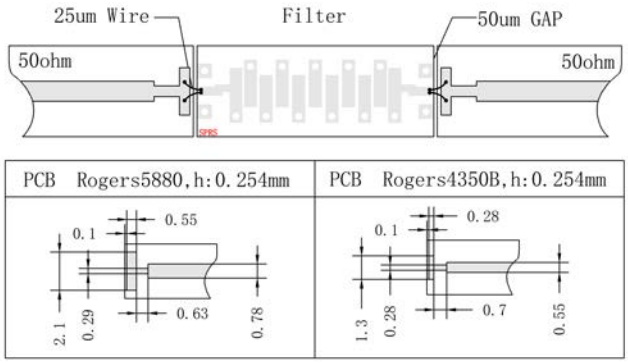
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



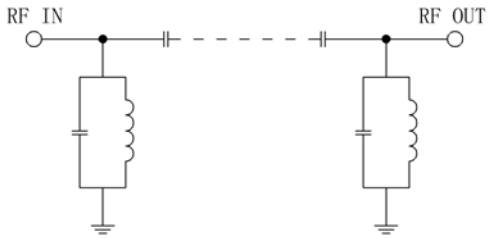
推荐装配图



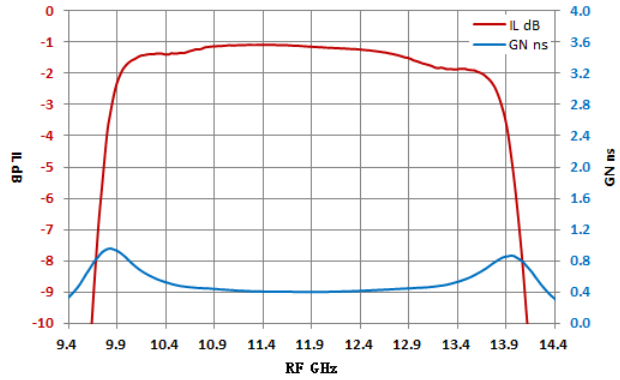
注意事项

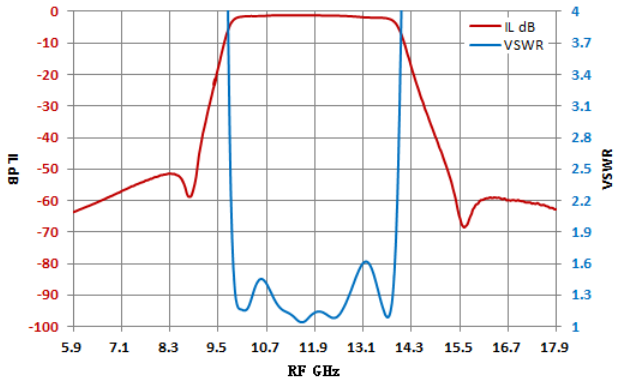
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

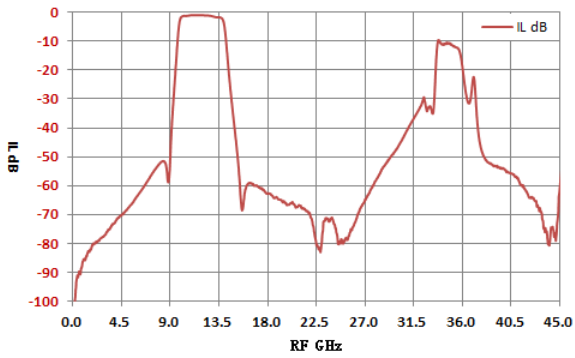
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

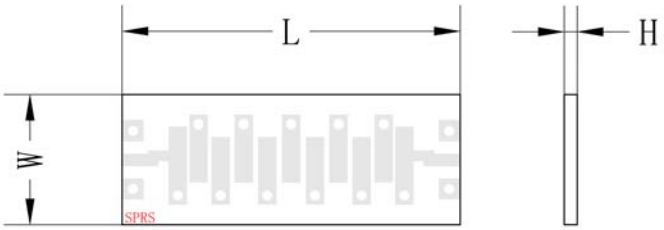
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	10.8	GHz
工作带宽	10.15-11.45	GHz
中心损耗	1.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-8.8GHz	dBc
带外抑制	50@12.9-23.0GHz	dBc

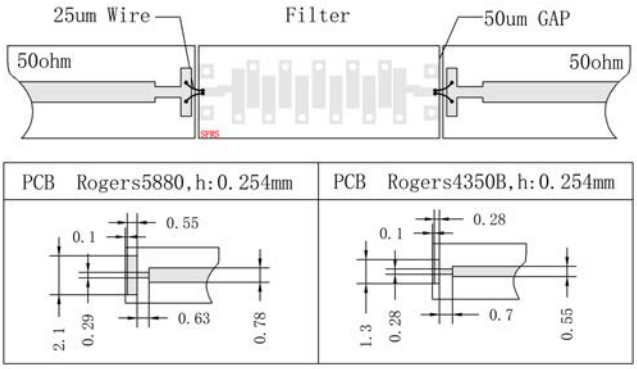
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：6.0，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.74mm,端口可互换;

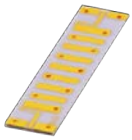
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

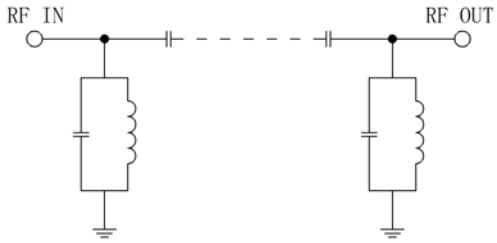
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

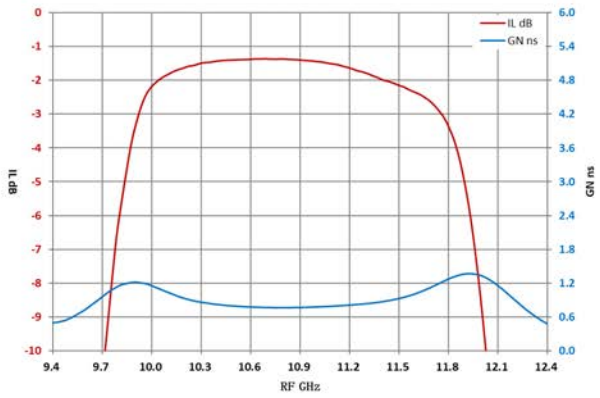
参考图

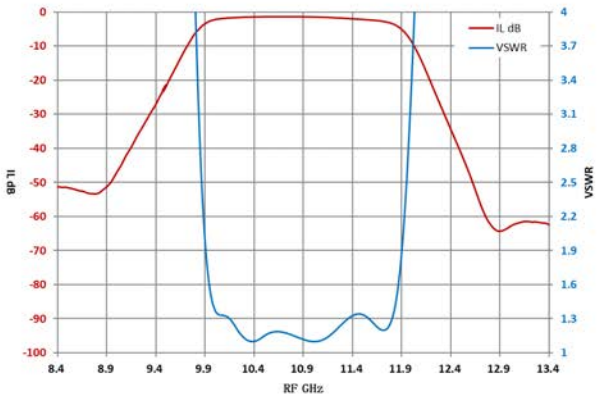


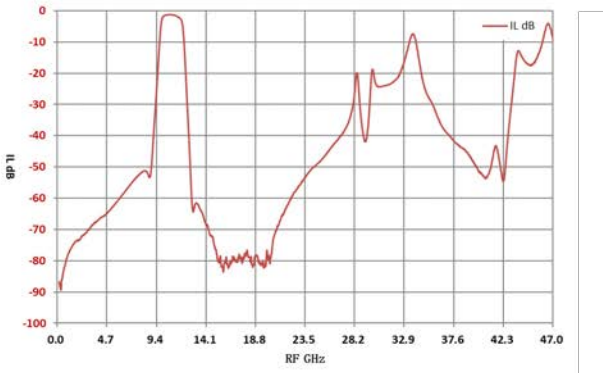
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



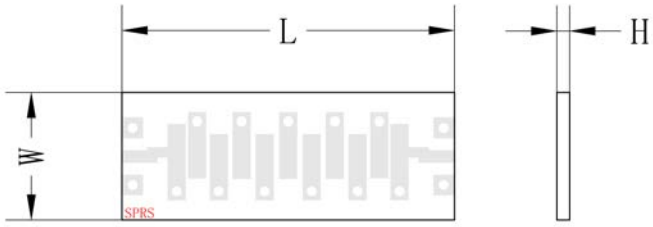
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	10.7	GHz
工作带宽	10.2-11.2	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-8.7GHz	dBc
带外抑制	40@12.5-25.0GHz	dBc

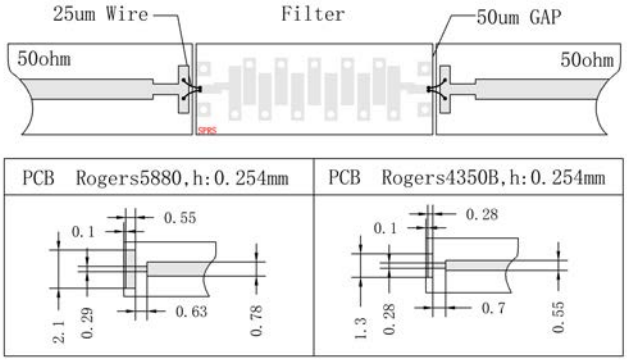
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



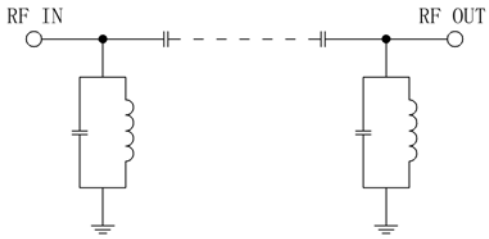
推荐装配图



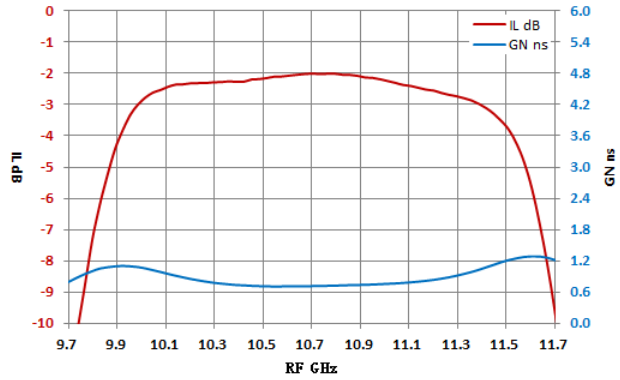
注意事项

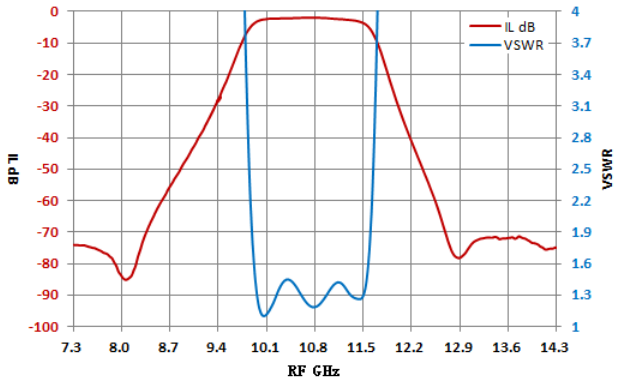
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

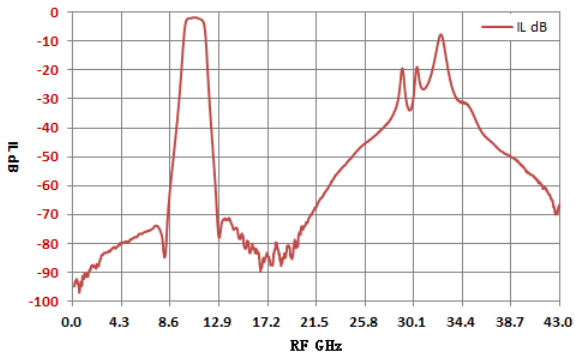
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

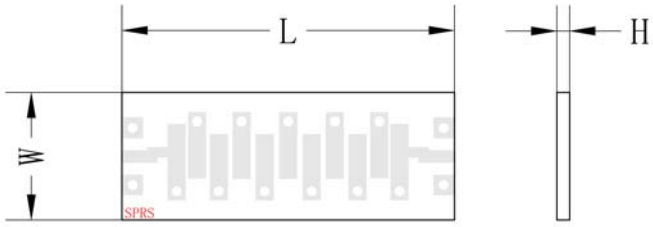
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	10.8	GHz
工作带宽	10.2-11.4	GHz
中心损耗	1.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-8.9GHz	dBc
带外抑制	40@12.8-19.2GHz	dBc

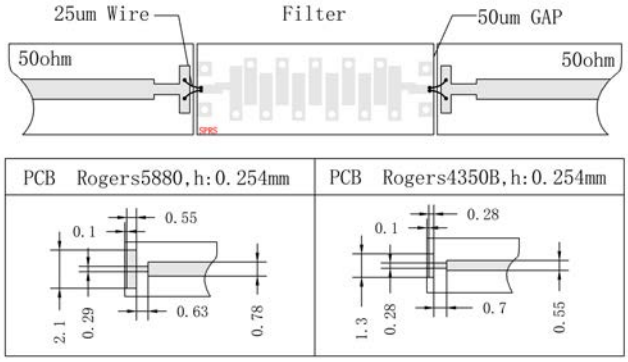
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：5.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



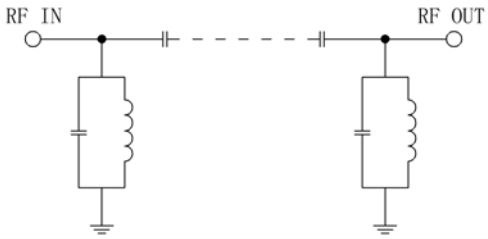
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

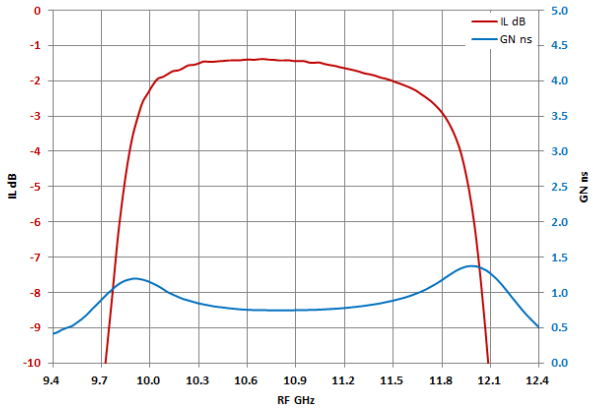
参考实物图

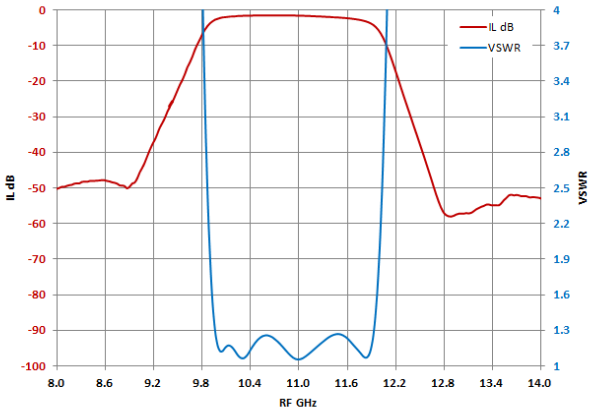


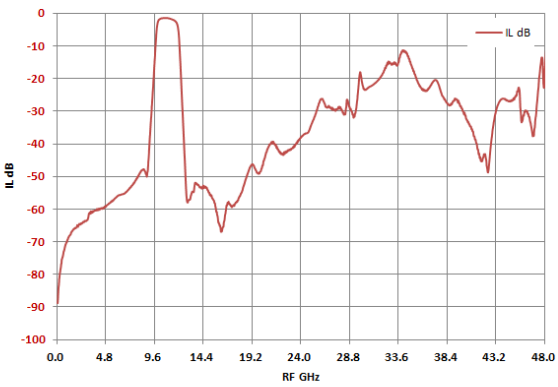
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



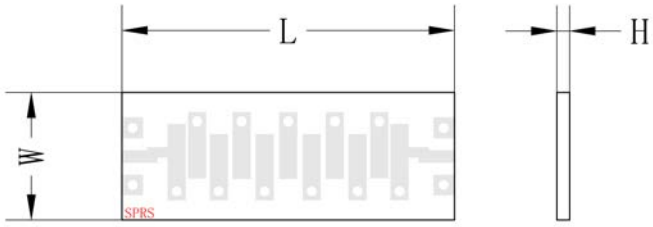
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	11.5	GHz
工作带宽	10.2-12.8	GHz
中心损耗	2.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-8.9GHz	dBc
带外抑制	40@14.3-25.0GHz	dBc

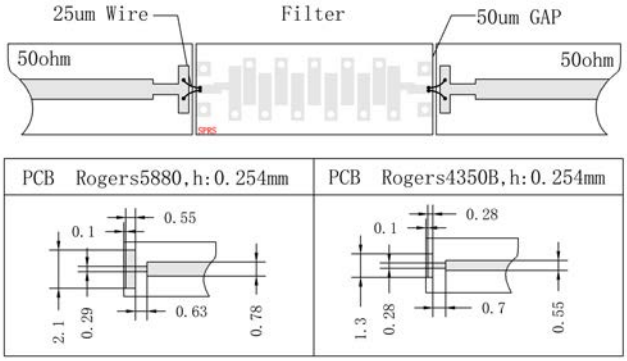
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.5，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



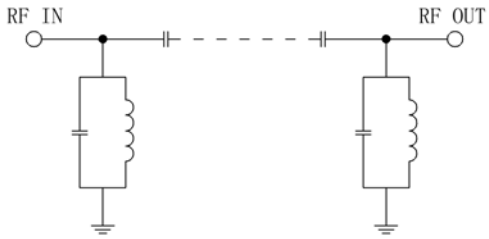
推荐装配图



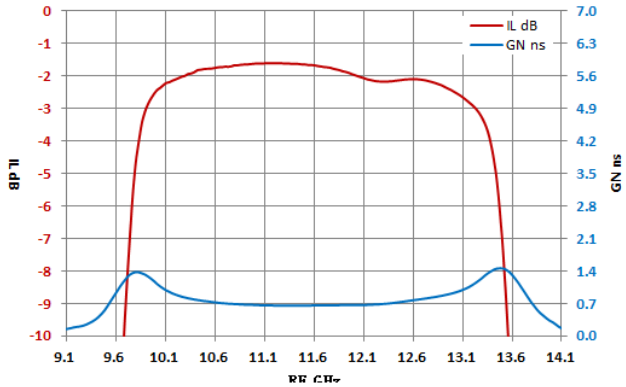
注意事项

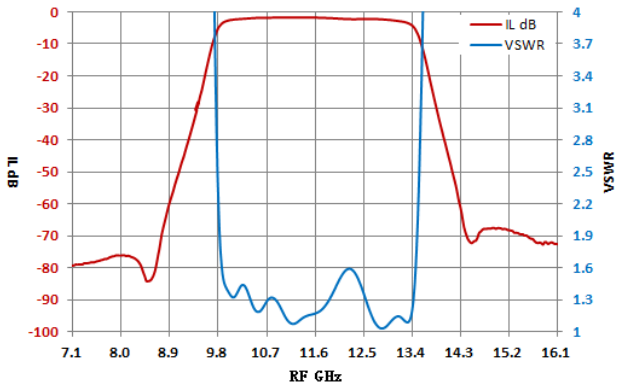
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

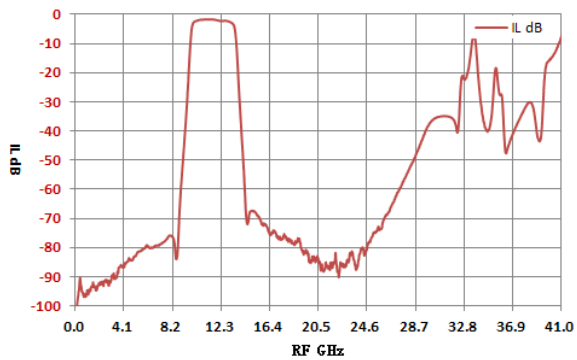
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



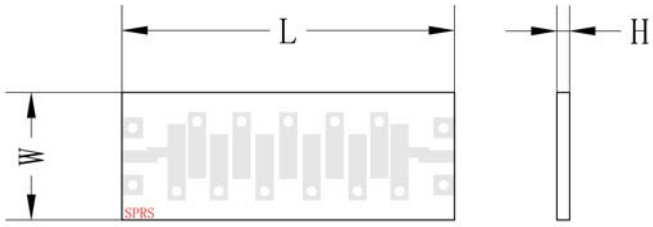
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	10.6	GHz
工作带宽	10.3-10.9	GHz
中心损耗	3.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-9.2GHz	dBc
带外抑制	40@12.5-18.0GHz	dBc

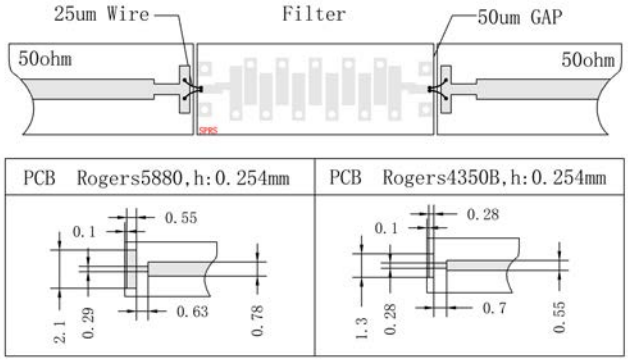
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：4.5，h：0.26

外形图：端口居中



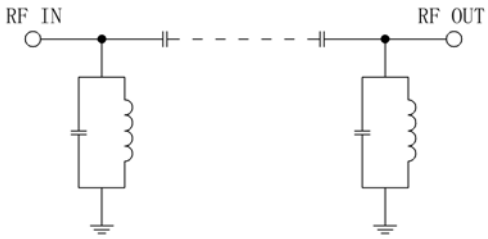
推荐装配图



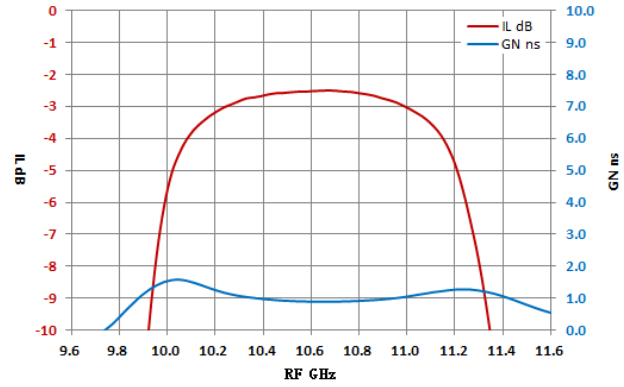
注意事项

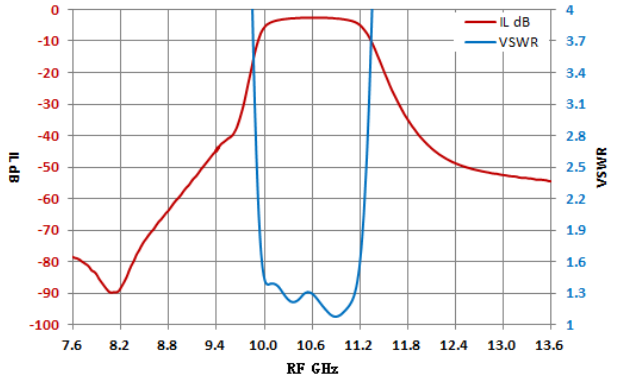
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

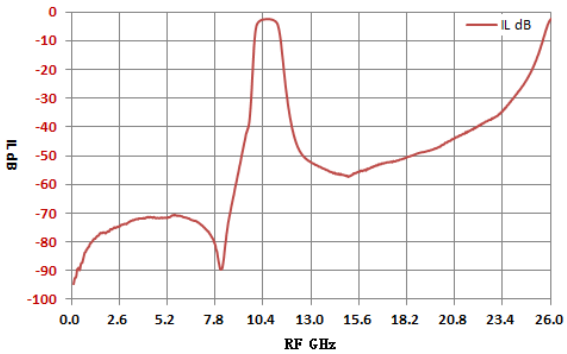
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



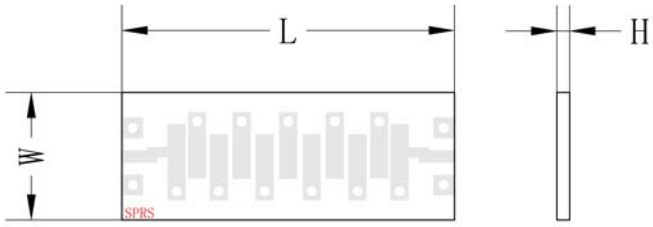
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	11.2	GHz
工作带宽	10.3-12.1	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-8.9GHz	dBc
带外抑制	40@13.7-27.0GHz	dBc

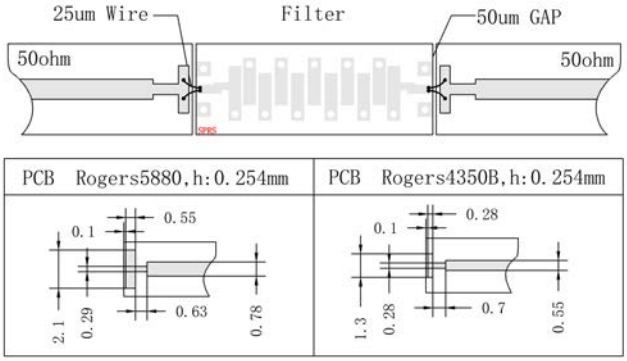
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



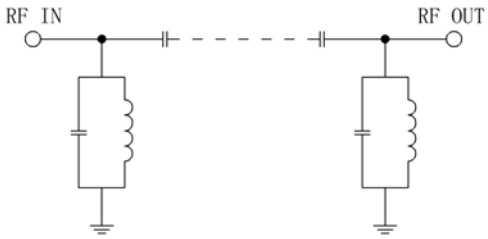
推荐装配图



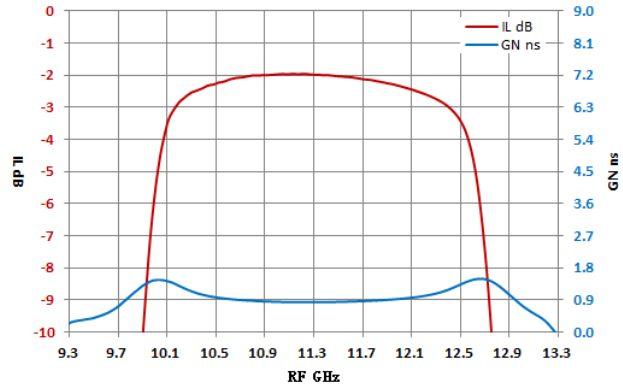
注意事项

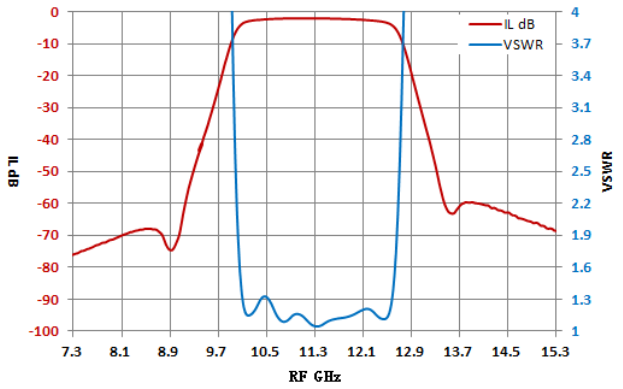
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

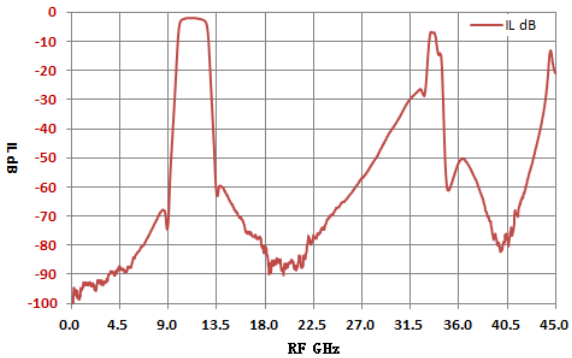
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

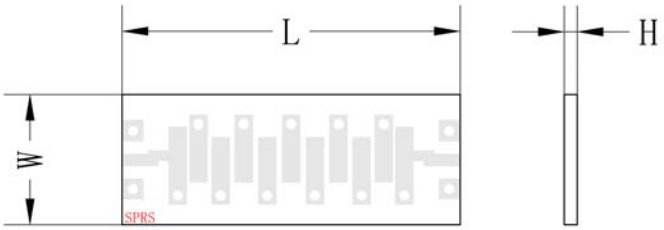
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	11.45	GHz
工作带宽	10.3-12.6	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-9.2GHz	dBc
带外抑制	40@13.9-29.0GHz	dBc

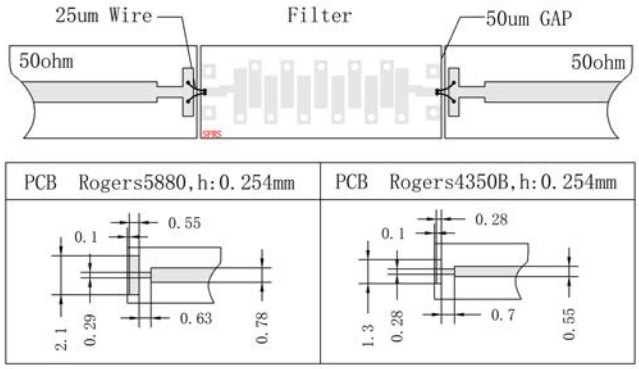
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：8.5，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.74mm,端口可互换;

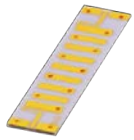
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

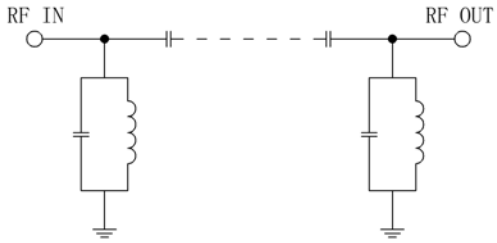
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

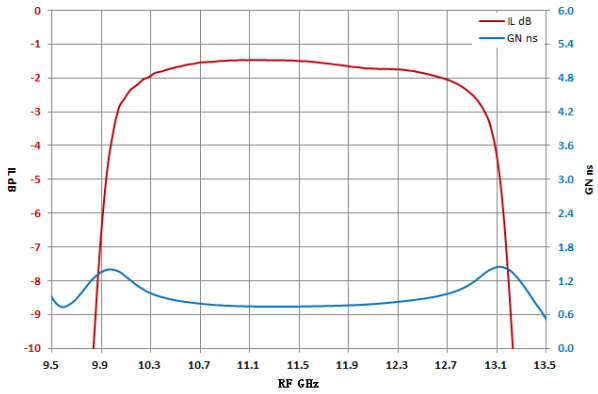
参考图

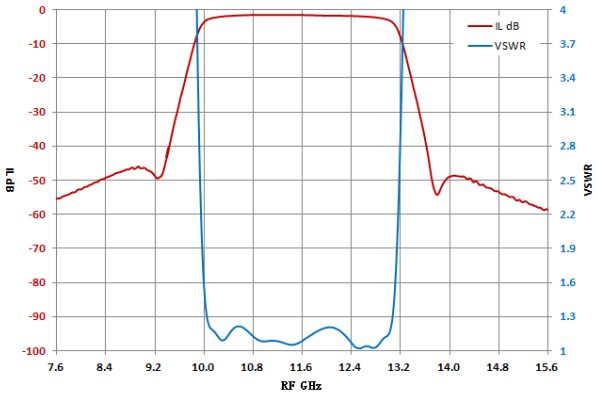


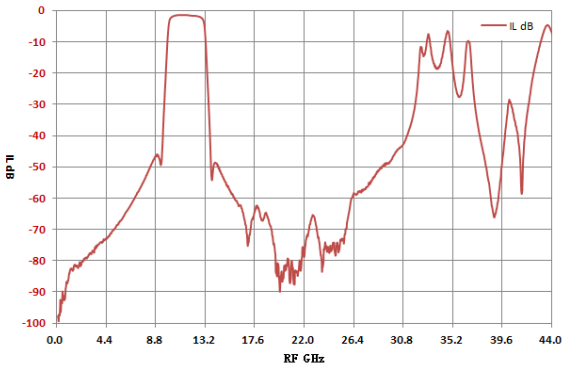
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



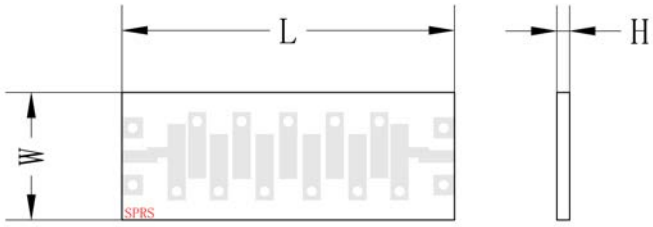
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	12.9	GHz
工作带宽	10.3-15.5	GHz
中心损耗	1.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-8.4GHz	dBc
带外抑制	40@17.6GHz	dBc

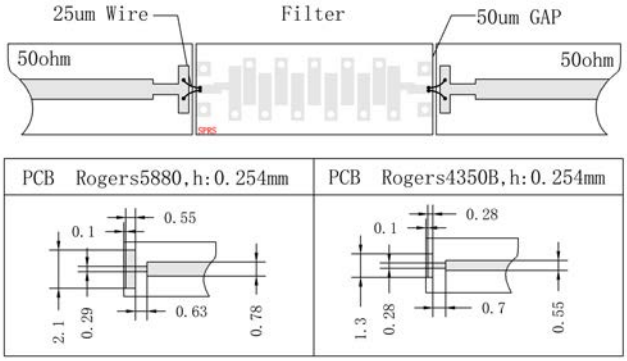
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



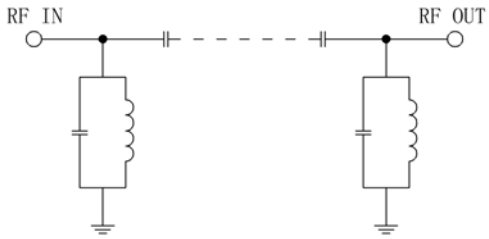
推荐装配图



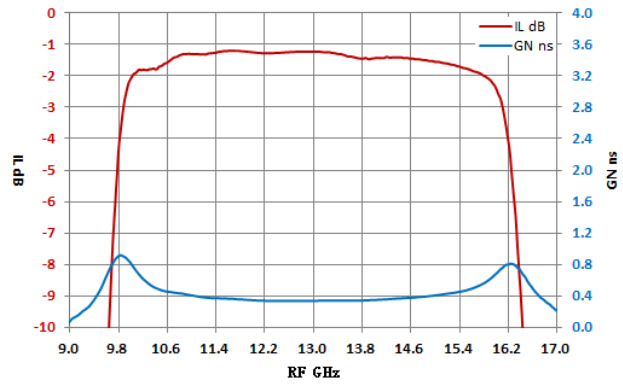
注意事项

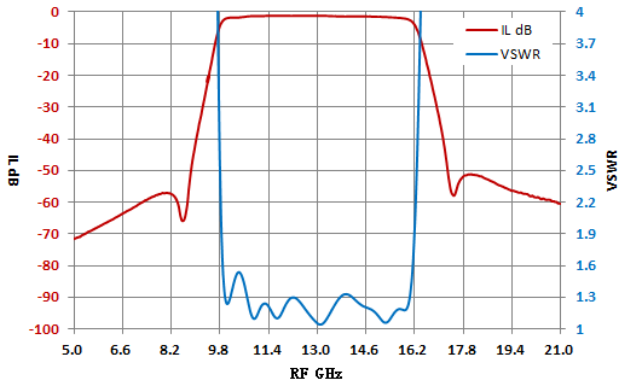
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

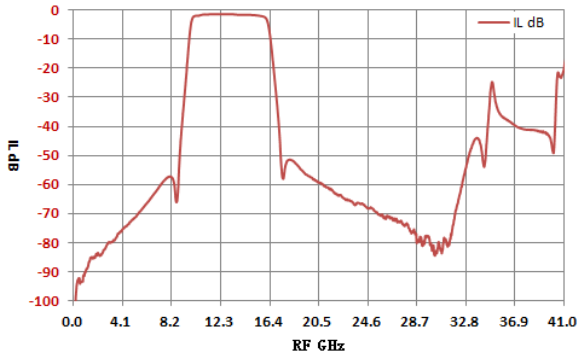
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



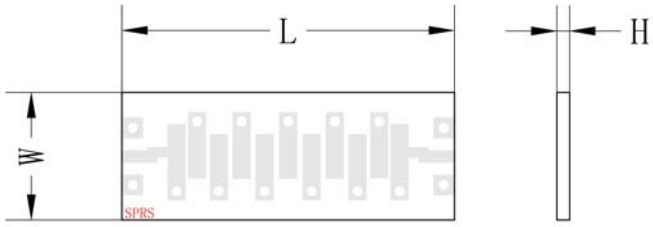
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	11.2	GHz
工作带宽	10.4-12.0	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	30@DC-9.5GHz	dBc
带外抑制	40@13.3-22.0GHz	dBc

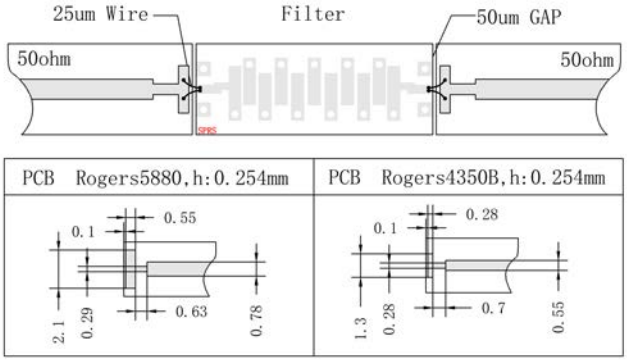
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：4.5，h：0.26

外形图：端口居中



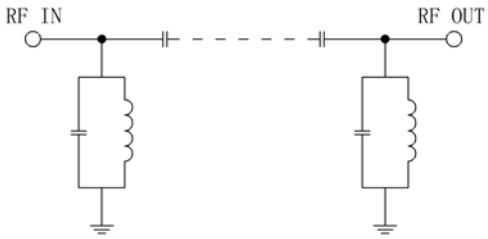
推荐装配图



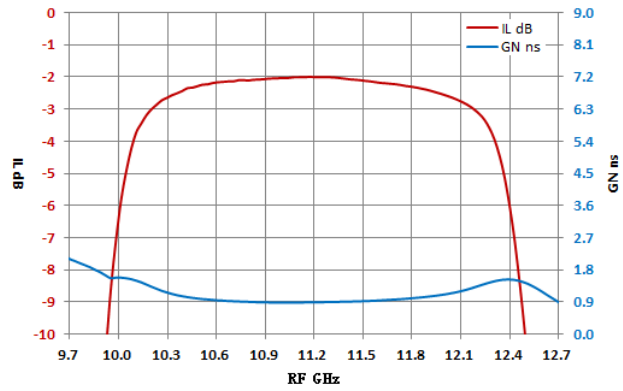
注意事项

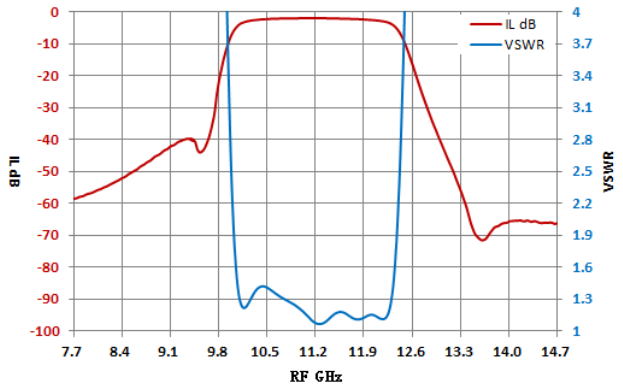
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

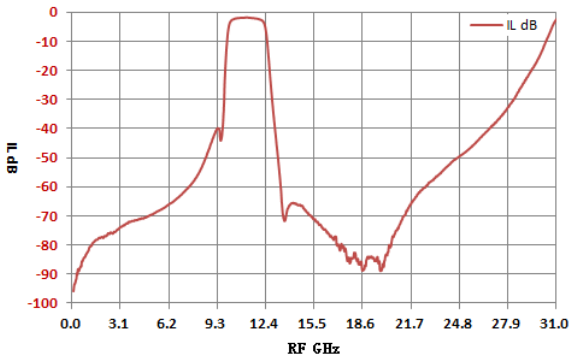
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

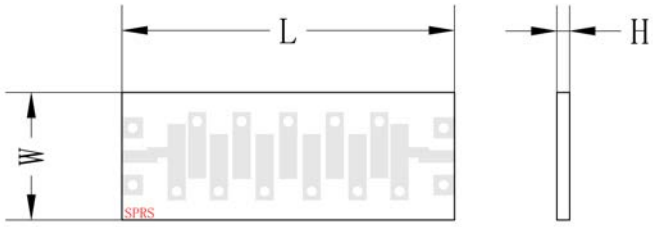
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	12.2	GHz
工作带宽	10.4-14.0	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-8.1GHz	dBc
带外抑制	40@15.8-26.0GHz	dBc

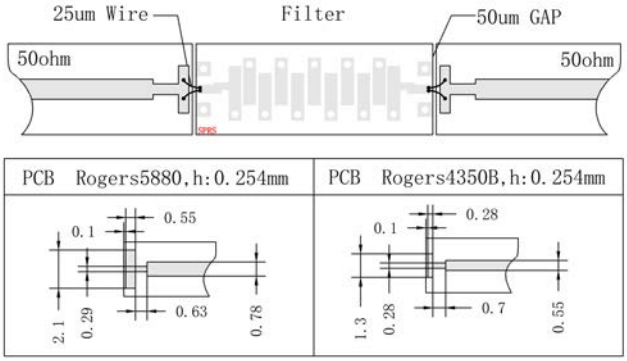
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：3.4，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



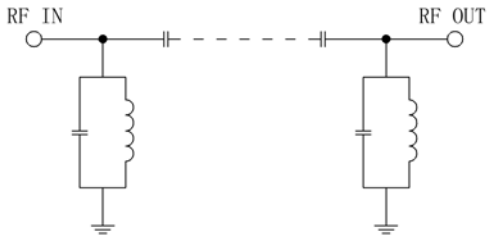
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.87mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

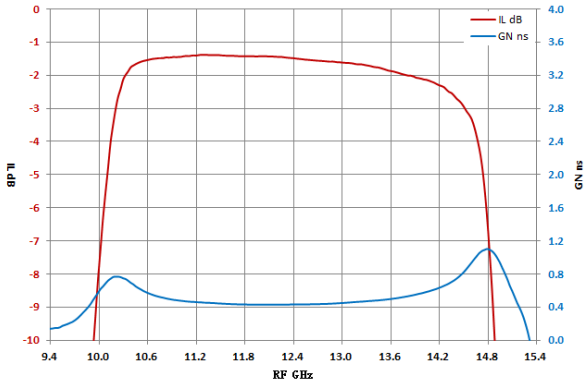
参考实物图

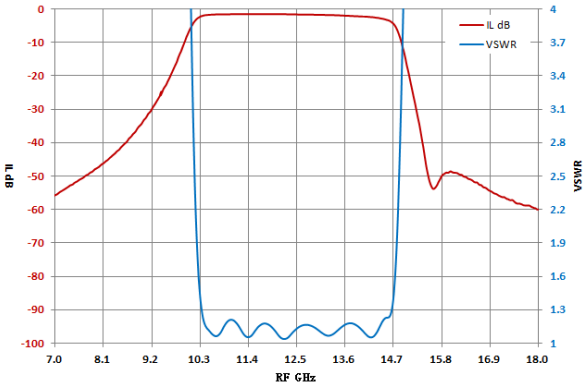


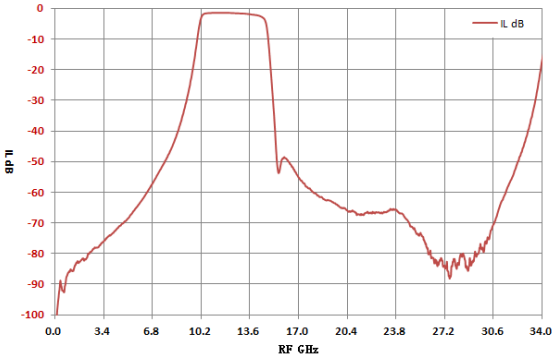
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

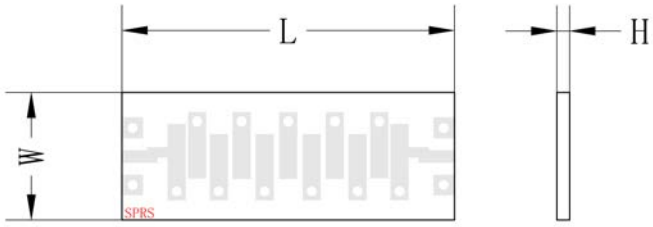
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	11.15	GHz
工作带宽	10.5-11.8	GHz
中心损耗	2.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-9.1GHz	dBc
带外抑制	40@13.4-27.0GHz	dBc

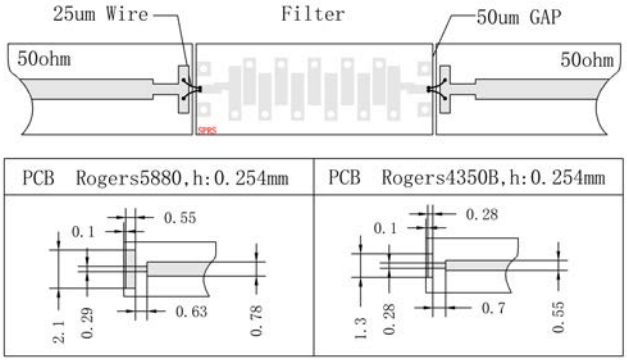
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



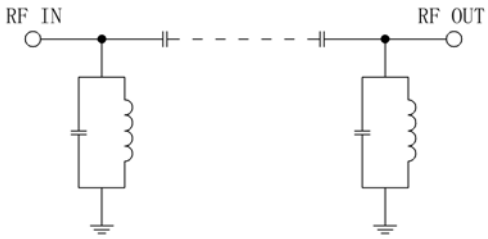
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

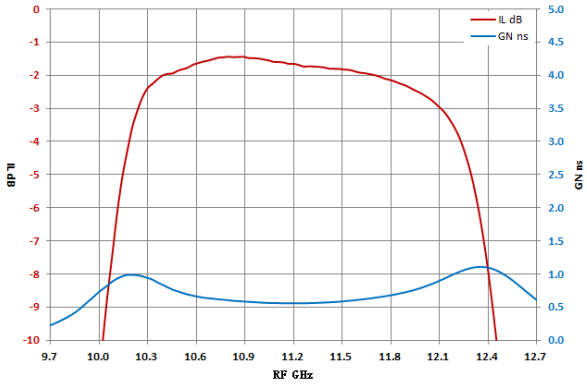
参考实物图

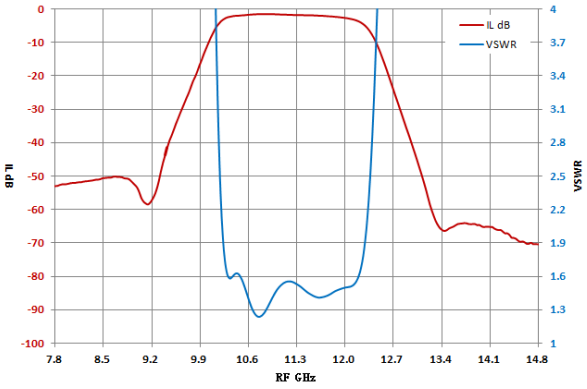


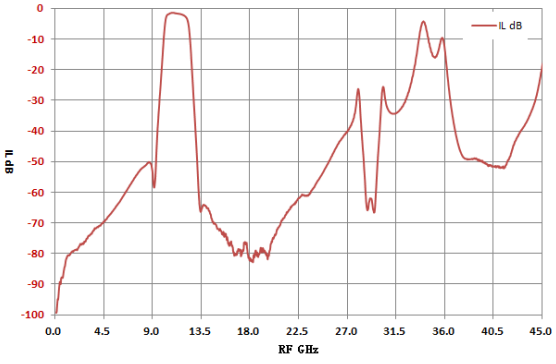
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



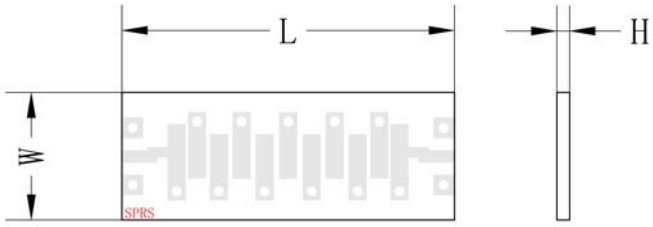
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	11.3	GHz
工作带宽	10.5-12.0	GHz
中心损耗	2.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-9.5GHz	dBc
带外抑制	40@13.2-29.0GHz	dBc

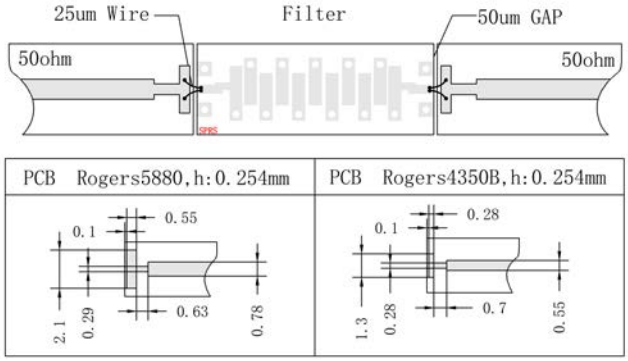
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.0，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



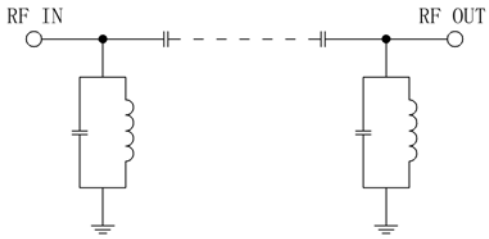
推荐装配图



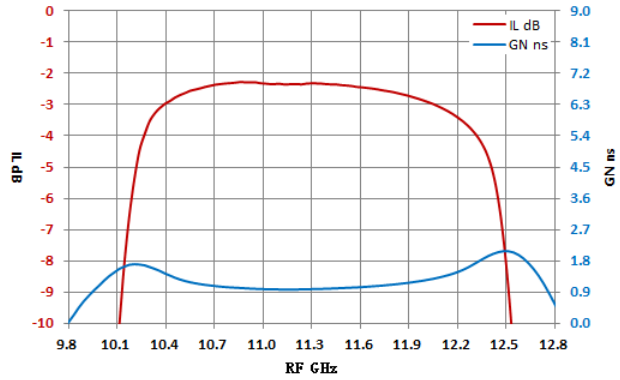
注意事项

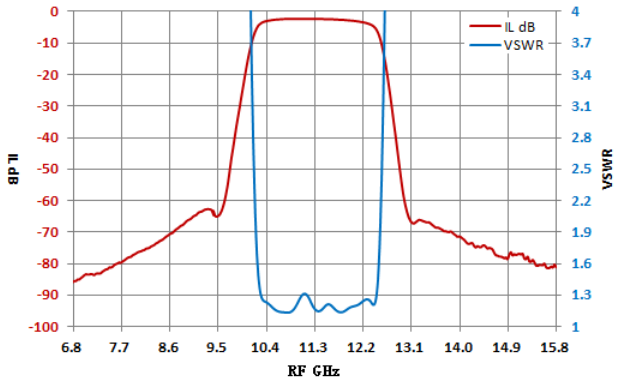
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

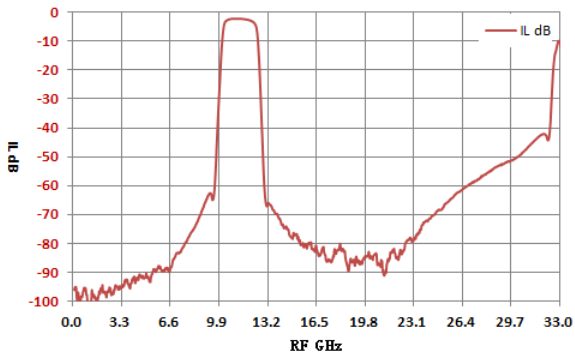
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



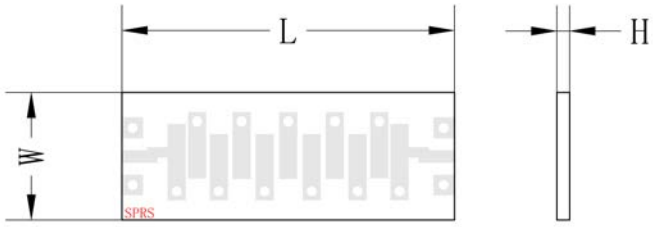
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	11.5	GHz
工作带宽	10.5-12.4	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	35@DC-9.5GHz	dBc
带外抑制	40@13.7-25.0GHz	dBc

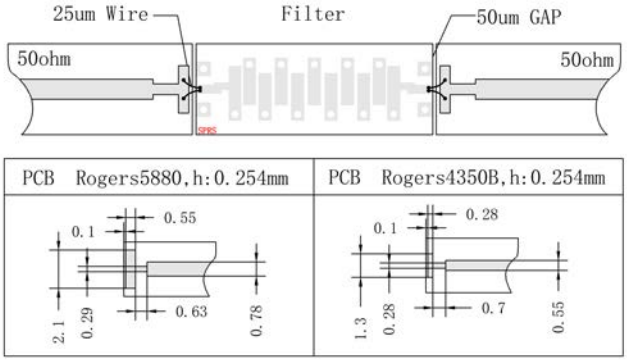
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



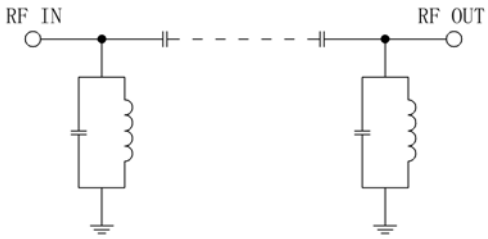
推荐装配图



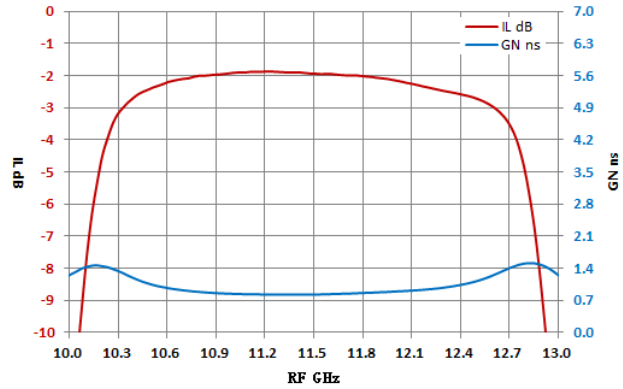
注意事项

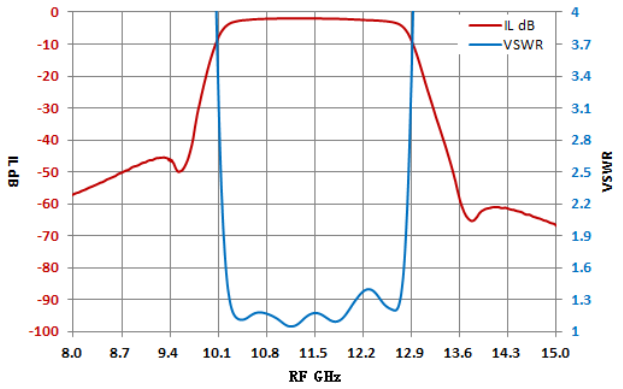
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

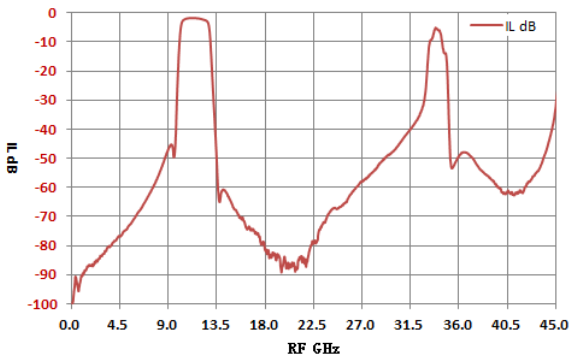
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



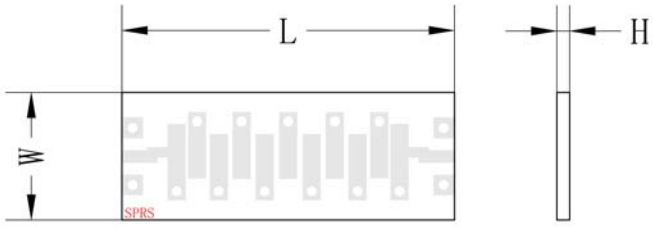
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	11.3	GHz
工作带宽	10.6-12.0	GHz
中心损耗	2.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-9.5GHz	dBc
带外抑制	40@13.3-23.0GHz	dBc

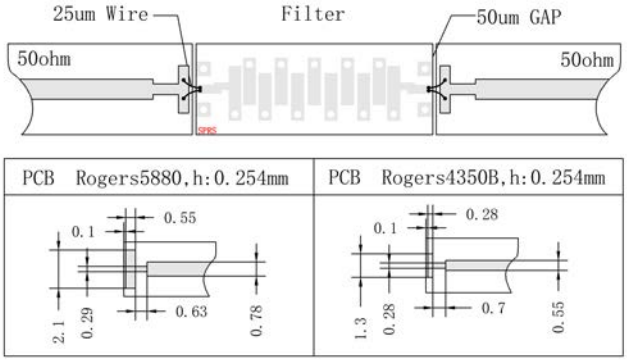
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



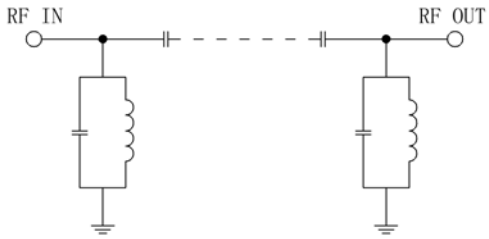
推荐装配图



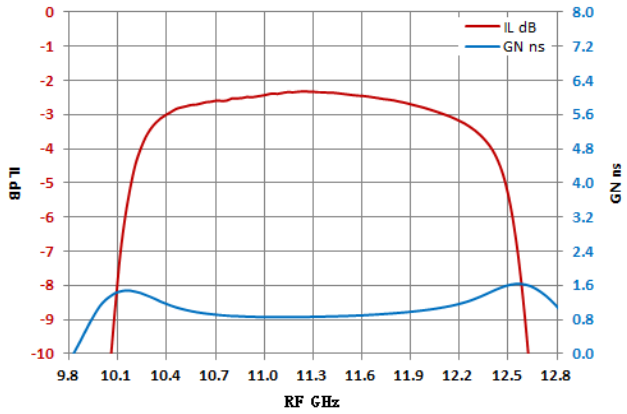
注意事项

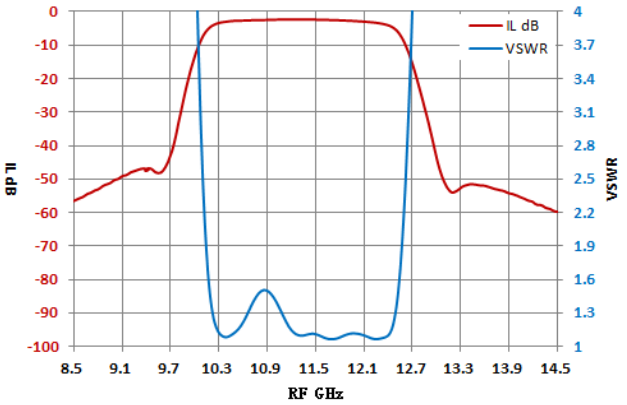
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

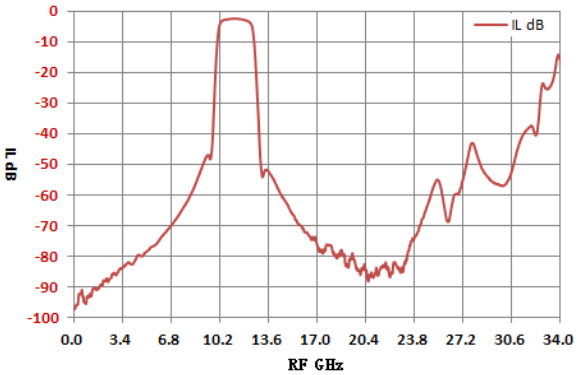
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



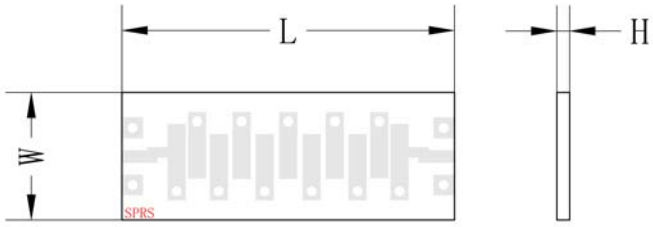
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	11.5	GHz
工作带宽	10.6-12.4	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-9.5GHz	dBc
带外抑制	40@13.8-28.0GHz	dBc

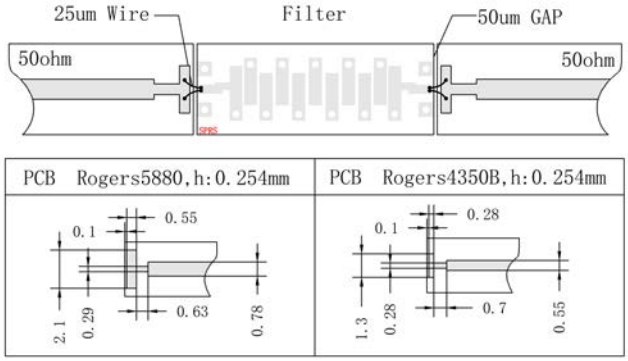
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



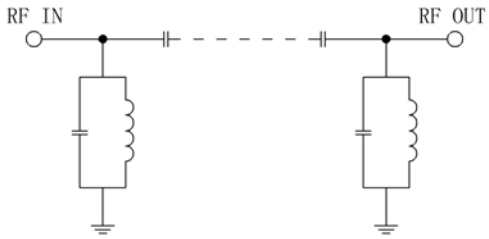
推荐装配图



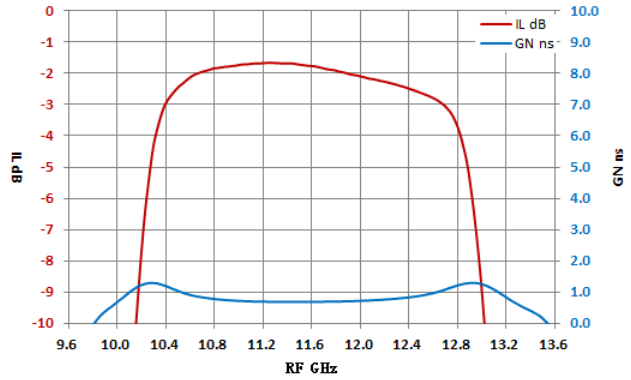
注意事项

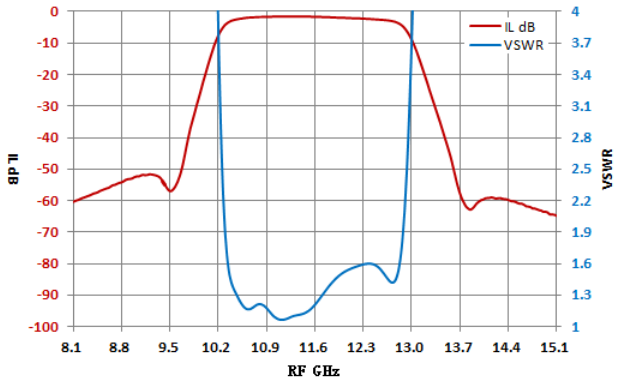
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

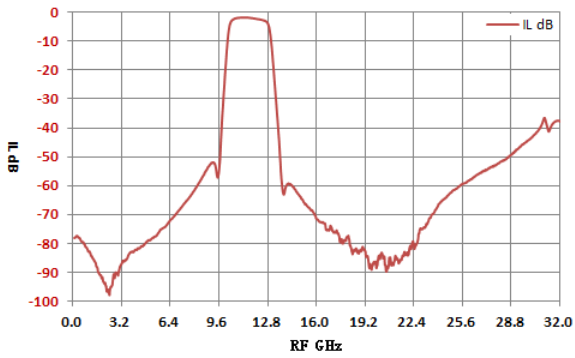
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

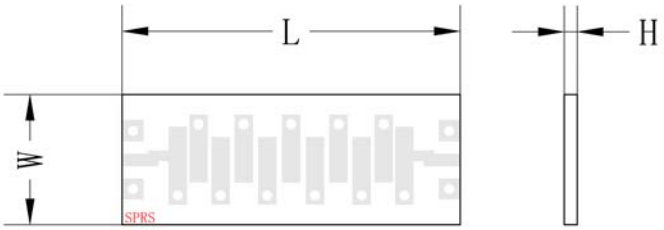
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	12.3	GHz
工作带宽	10.6-14.0	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-9.2GHz	dBc
带外抑制	40@15.8-30.0GHz	dBc

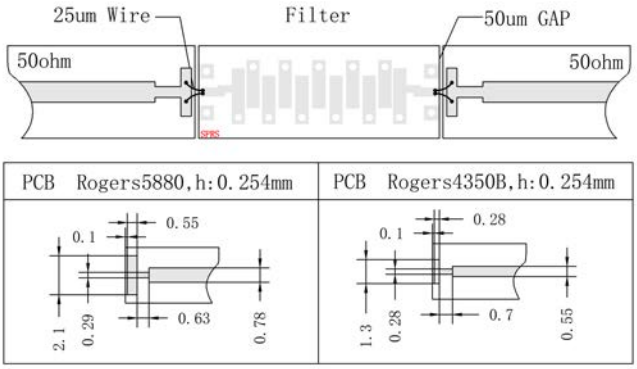
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：7.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.74mm,端口可互换;

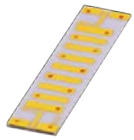
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

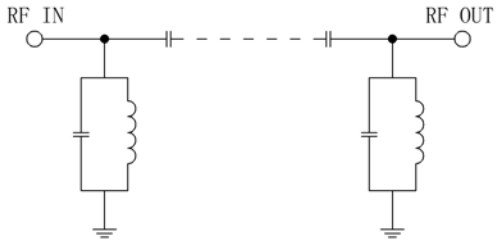
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

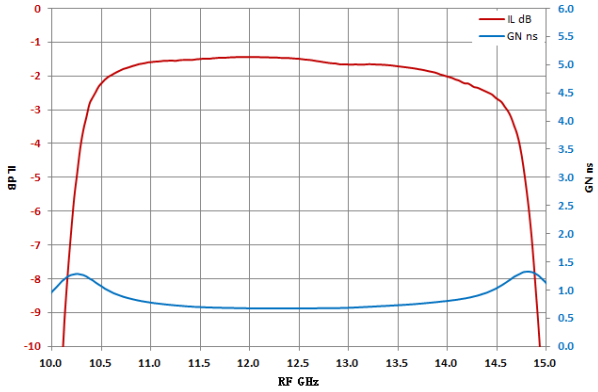
参考图

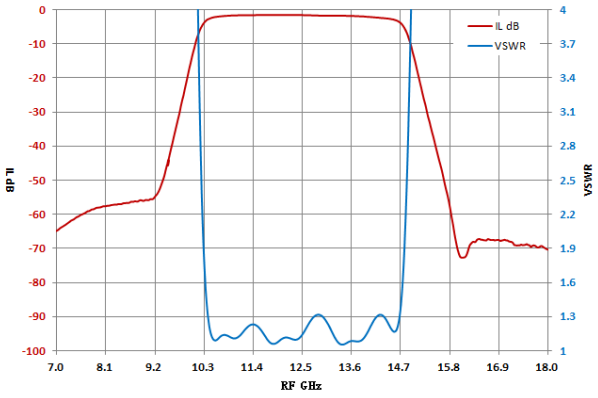


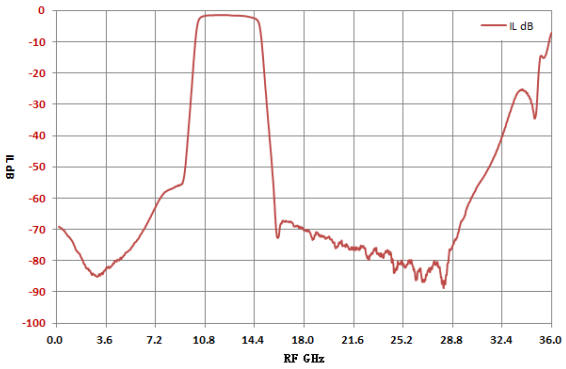
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

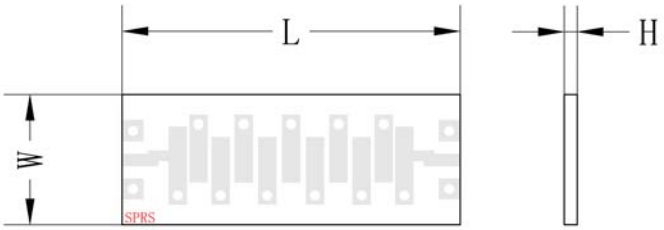
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	11.2	GHz
工作带宽	10.7-11.7	GHz
中心损耗	1.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.6	ns
带外抑制	40@DC-9.7GHz	dBc
带外抑制	40@12.6-28.0GHz	dBc

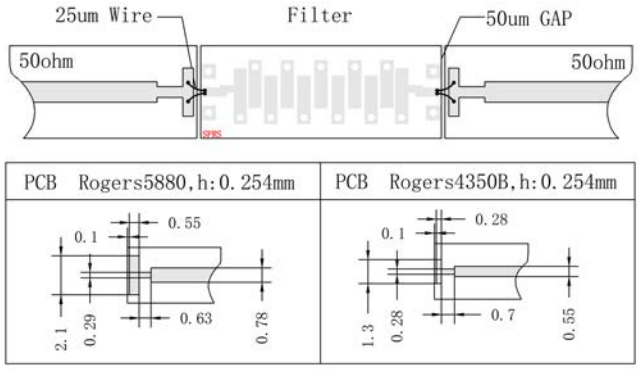
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：9.0，W：3.0，h：0.39

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.61mm,端口可互换;

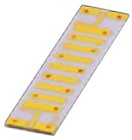
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

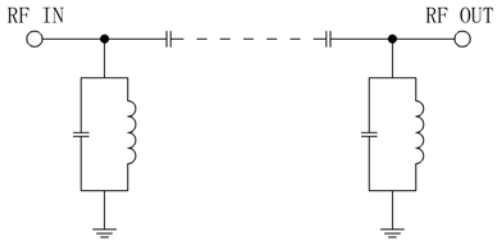
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

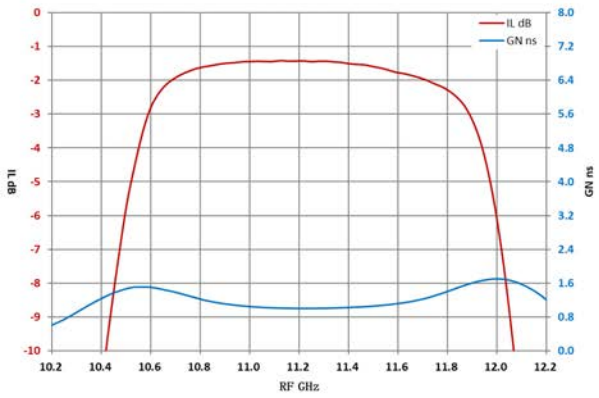
参考图

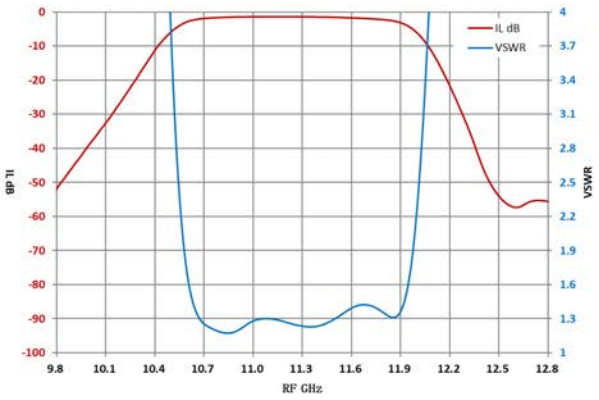


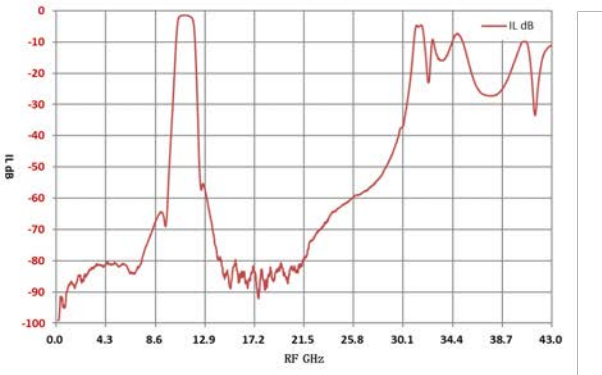
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

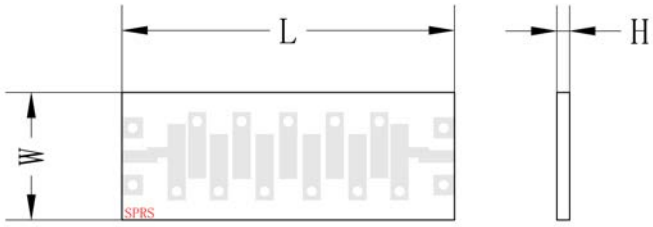
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	12.35	GHz
工作带宽	10.7-14.0	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-8.1GHz	dBc
带外抑制	40@15.8-27.0GHz	dBc

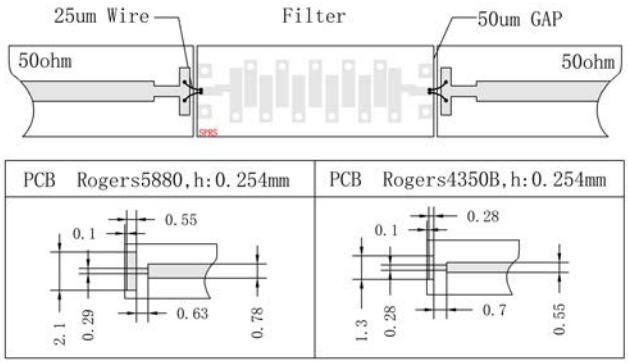
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



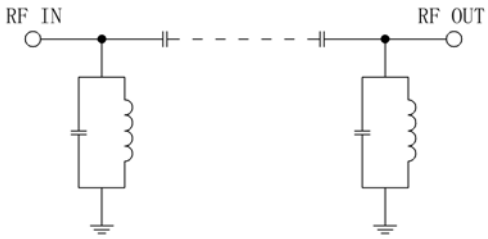
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

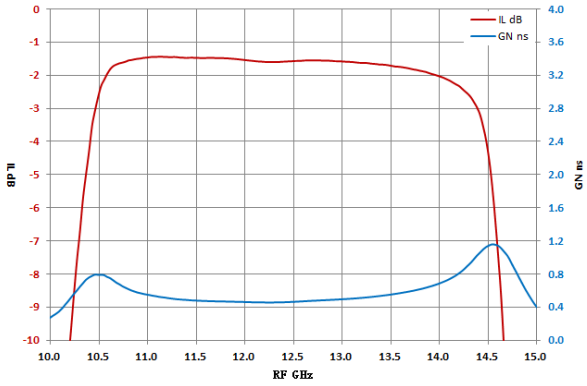
参考实物图

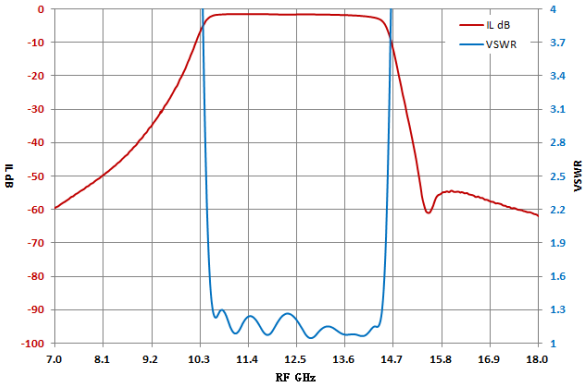


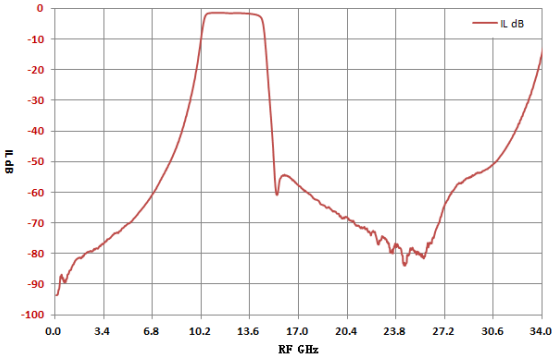
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



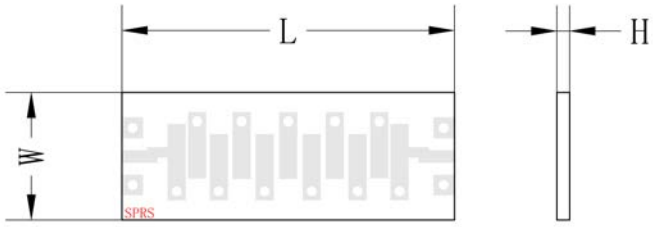
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	11.1	GHz
工作带宽	10.8-11.4	GHz
中心损耗	3.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-9.7GHz	dBc
带外抑制	40@13.0-19.0GHz	dBc

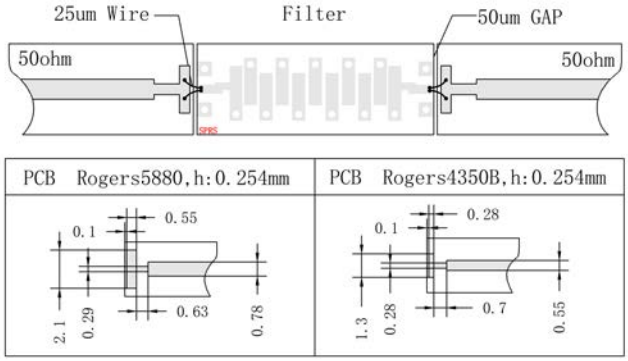
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：4.5，h：0.26

外形图：端口居中



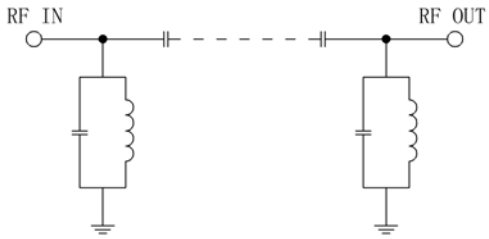
推荐装配图



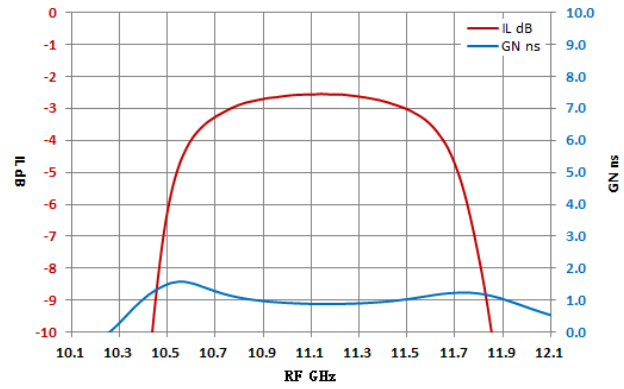
注意事项

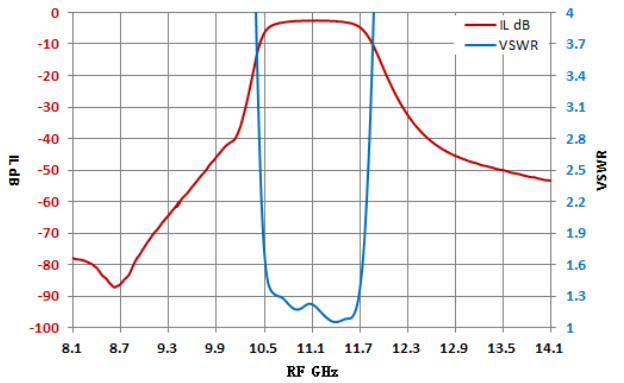
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

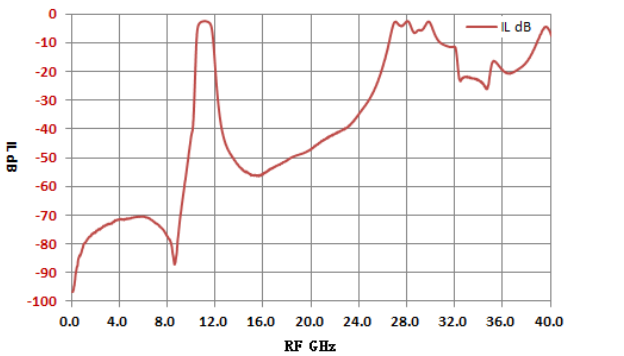
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



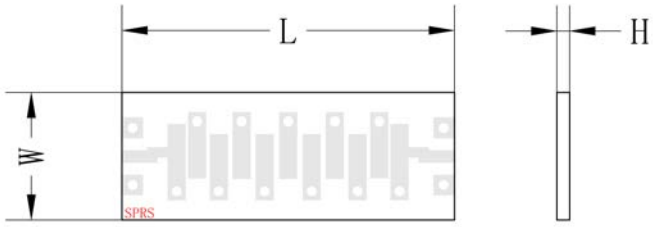
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	11.9	GHz
工作带宽	10.8-13.0	GHz
中心损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-8.8GHz	dBc
带外抑制	35@14.2-26.0GHz	dBc

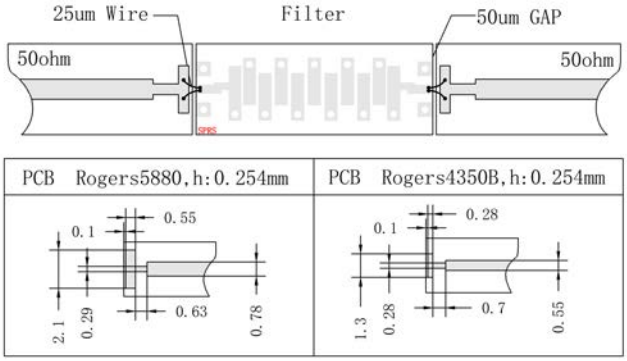
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



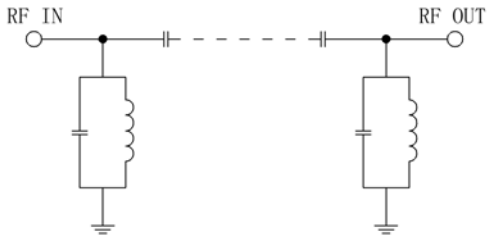
推荐装配图



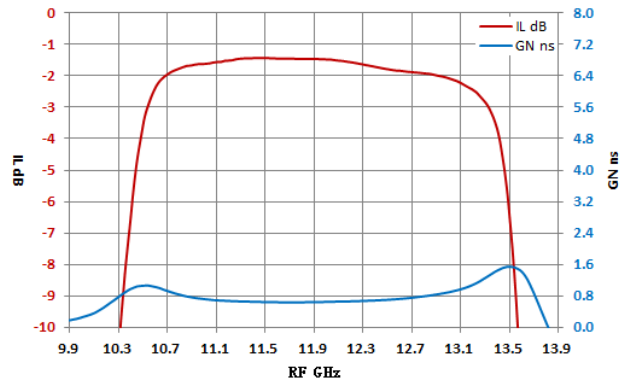
注意事项

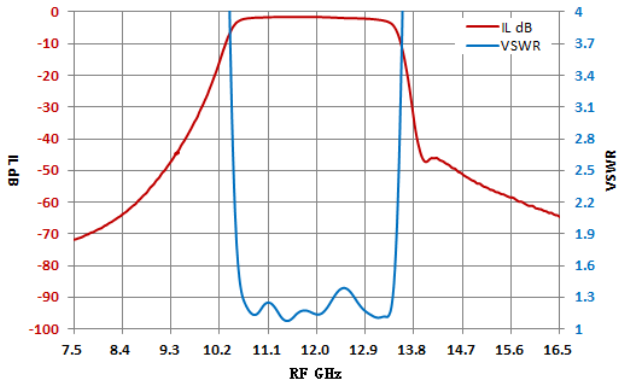
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

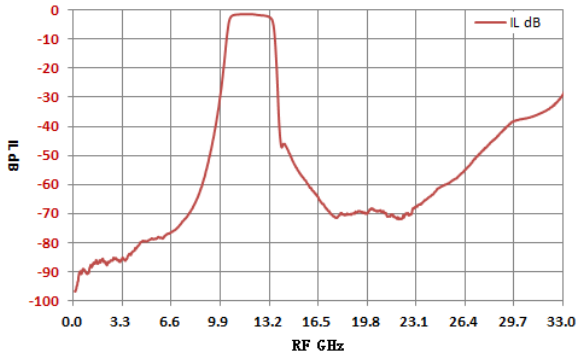
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



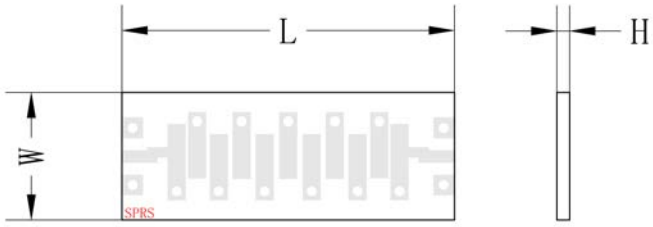
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	12.4	GHz
工作带宽	10.8-14.0	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-9.5GHz	dBc
带外抑制	40@15.7-28.0GHz	dBc

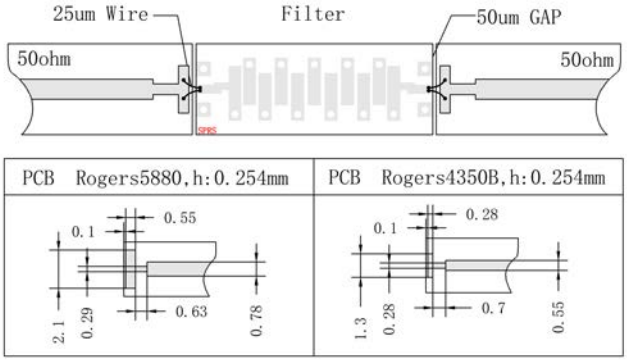
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



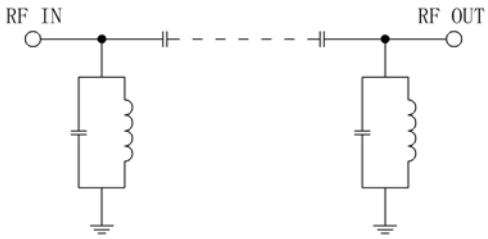
推荐装配图



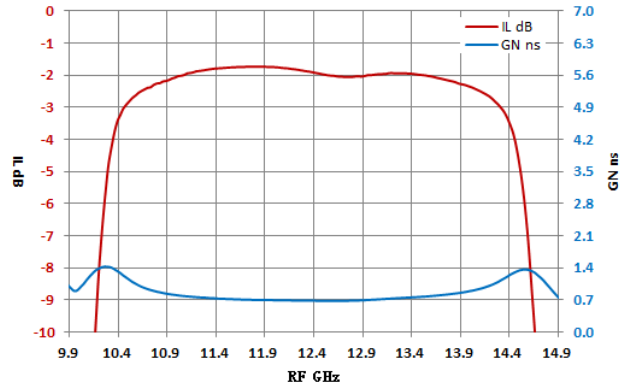
注意事项

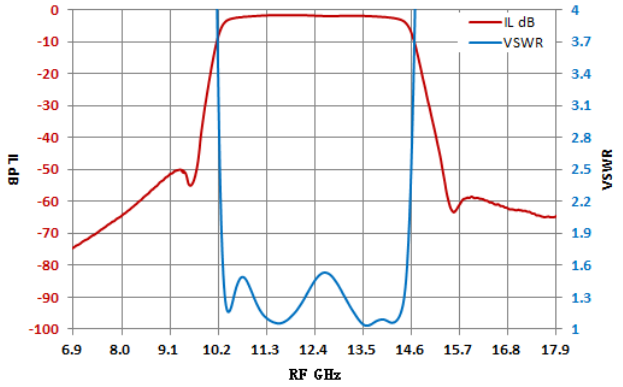
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

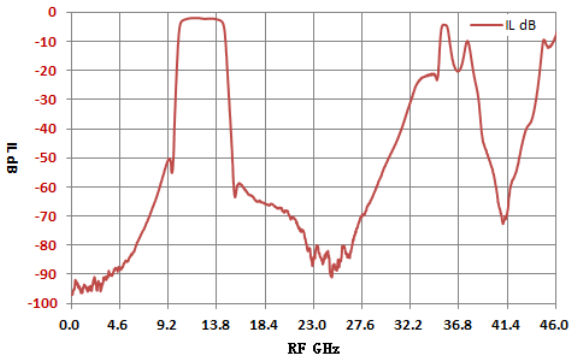
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

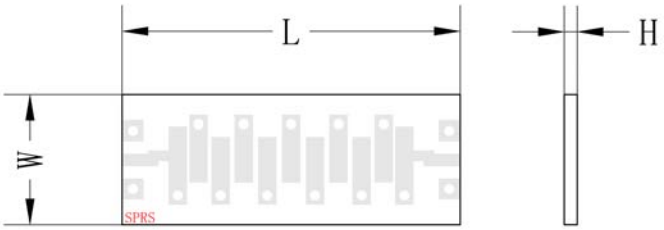
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	14.8	GHz
工作带宽	10.8-18.8	GHz
中心损耗	1.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	50@DC-8.9GHz	dBc
带外抑制	60@23.0-30.0GHz	dBc

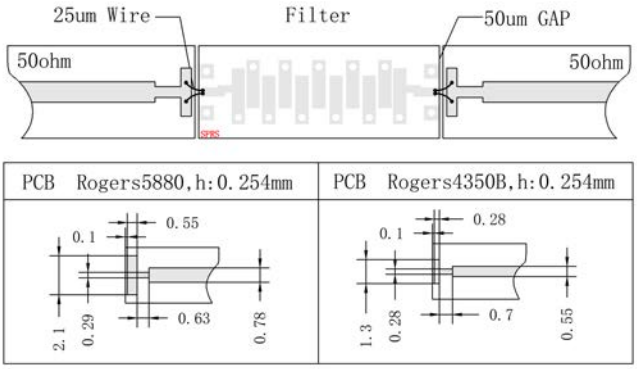
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：6.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

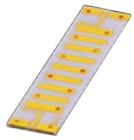
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

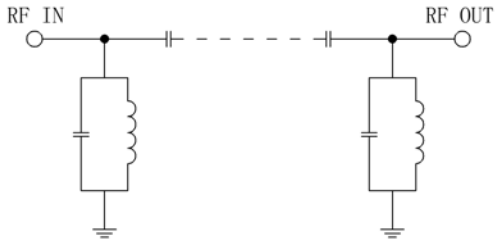
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

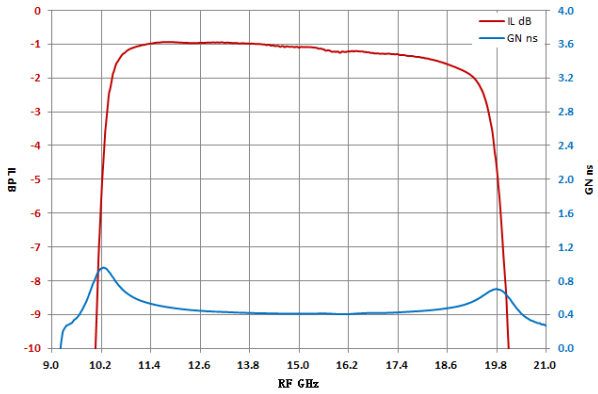
参考图

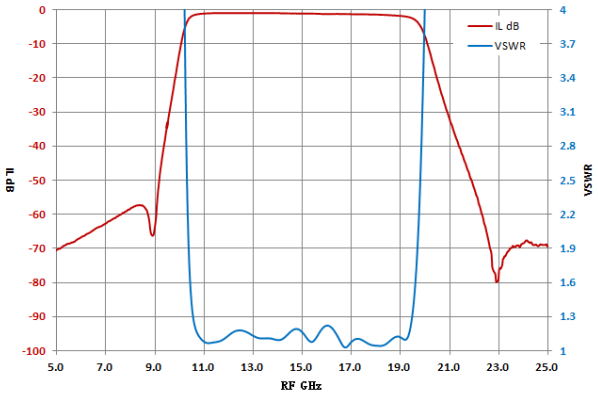


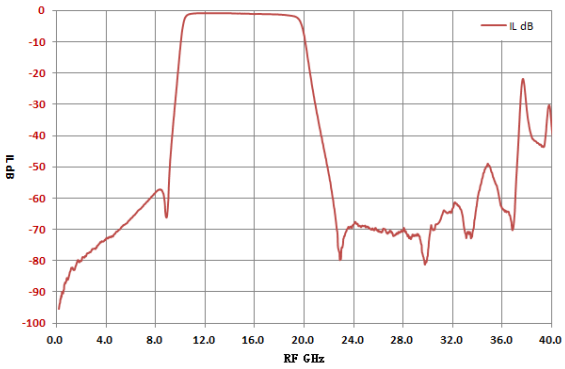
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



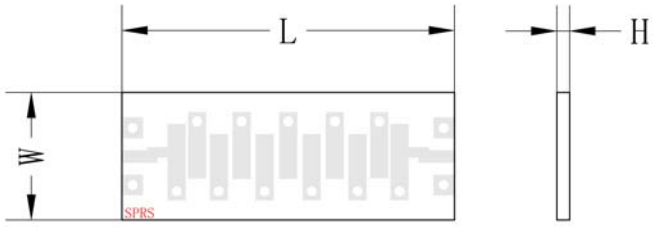
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	11.7	GHz
工作带宽	10.9-12.5	GHz
中心损耗	2.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	30@DC-10.0GHz	dBc
带外抑制	40@14.0-22.0GHz	dBc

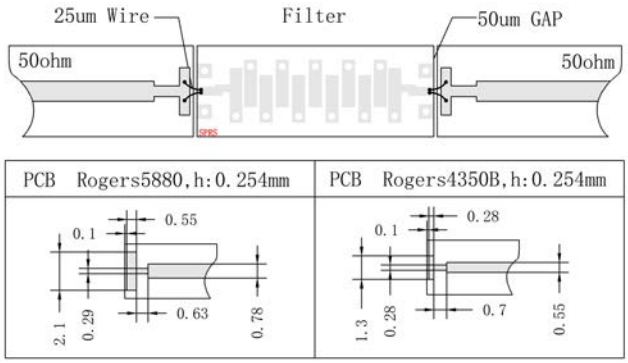
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：4.5，h：0.26

外形图：端口居中



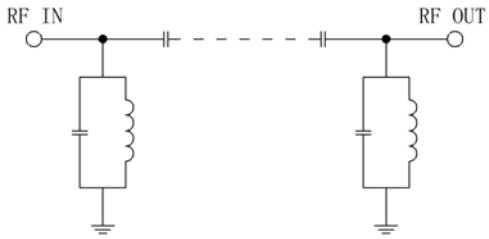
推荐装配图



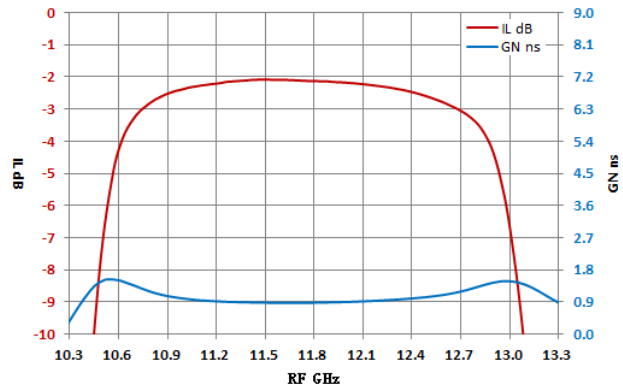
注意事项

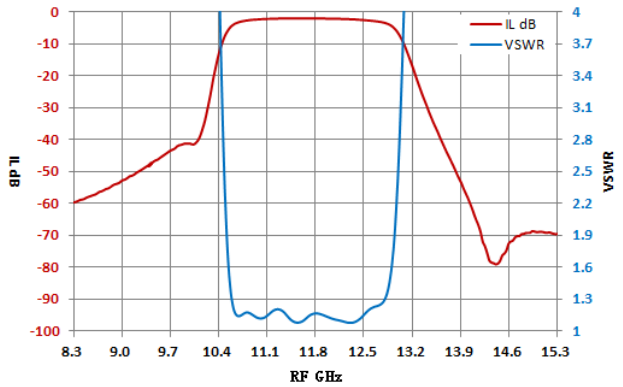
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

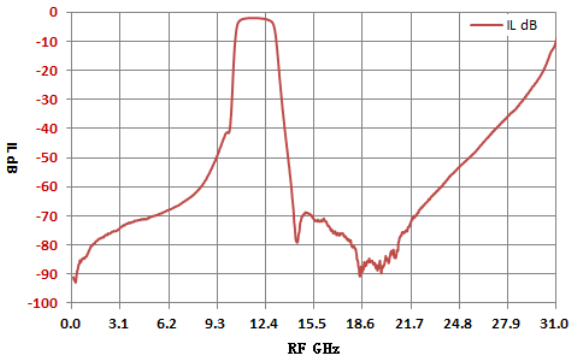
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



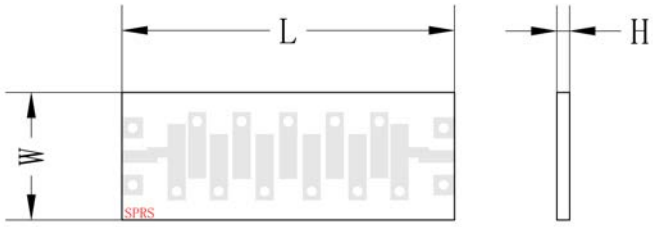
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	11.8	GHz
工作带宽	10.9-12.7	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-9.4GHz	dBc
带外抑制	40@14.0-23.0GHz	dBc

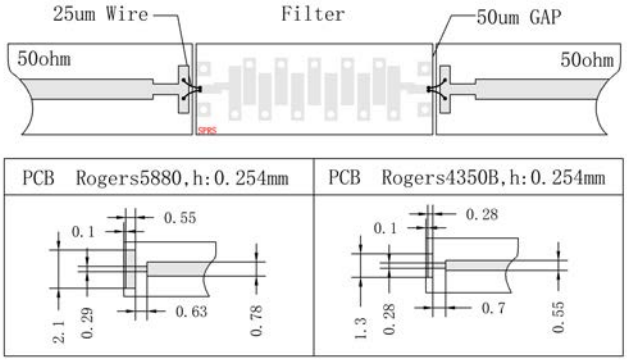
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.0，W：5.0，h：0.26

外形图：端口居中



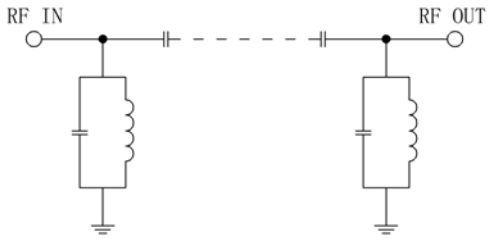
推荐装配图



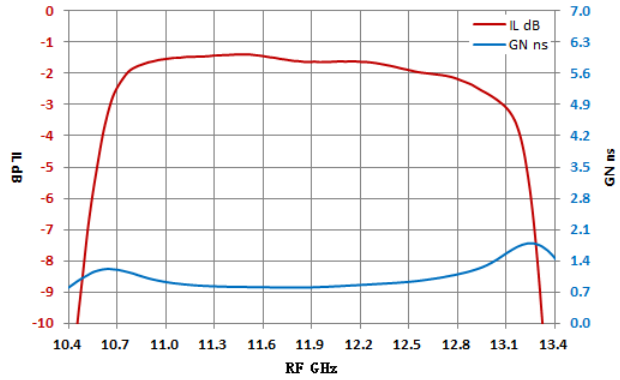
注意事项

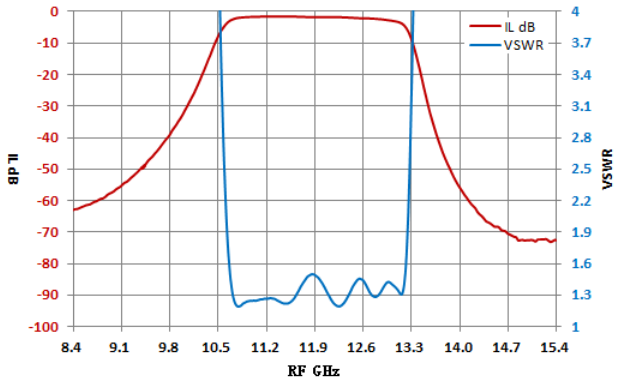
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

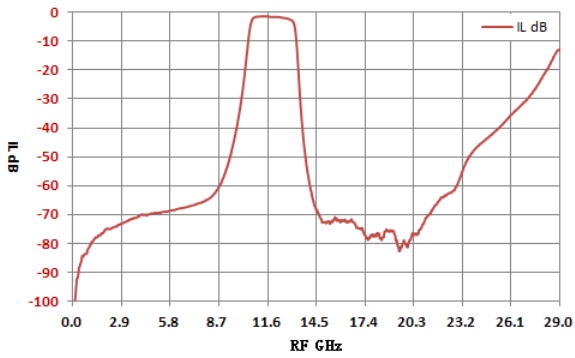
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

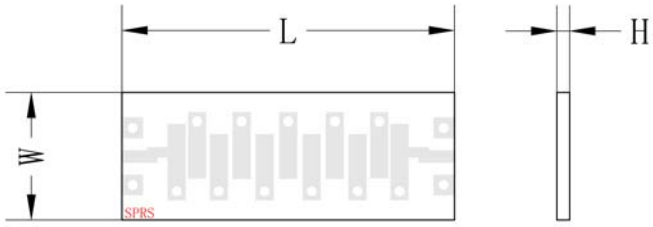
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	11.05	GHz
工作带宽	11.0-11.1	GHz
中心损耗	4.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-10.4GHz	dBc
带外抑制	40@11.6-26.6GHz	dBc

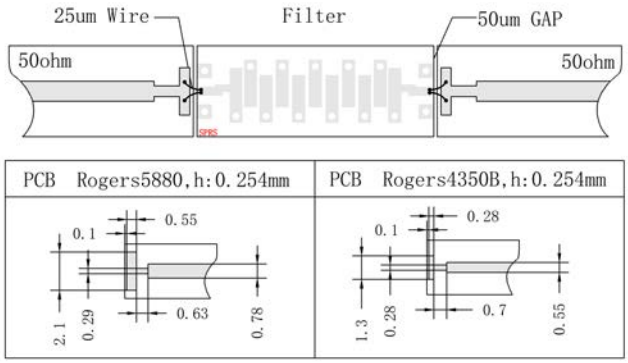
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.5，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



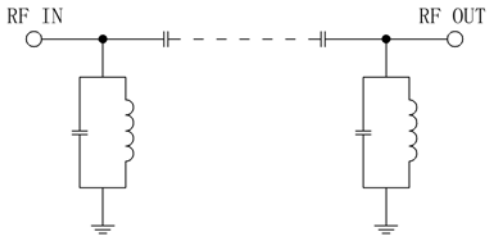
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

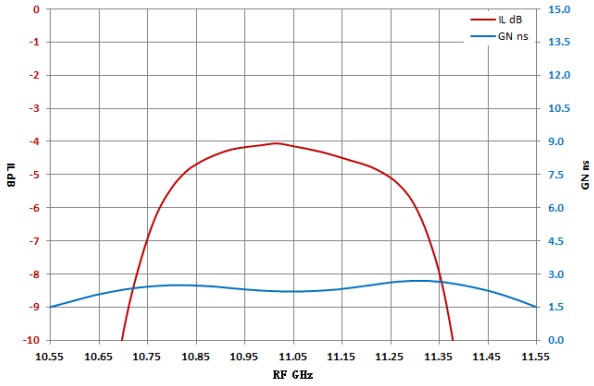
参考实物图

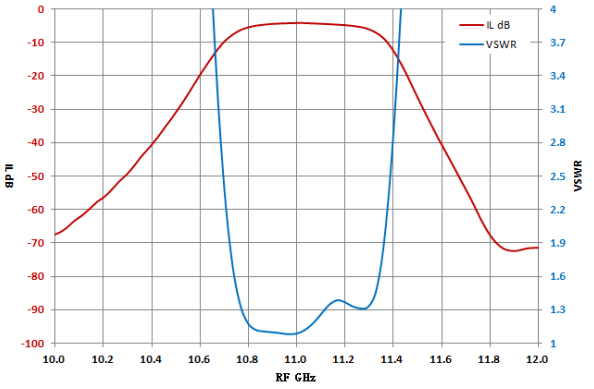


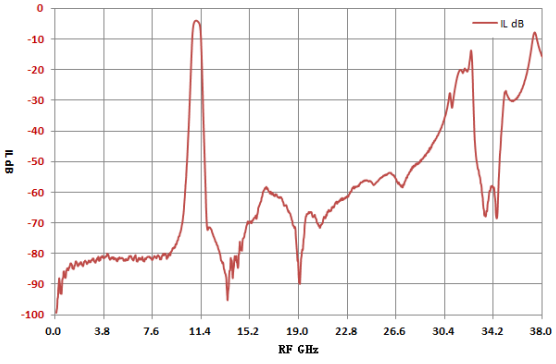
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

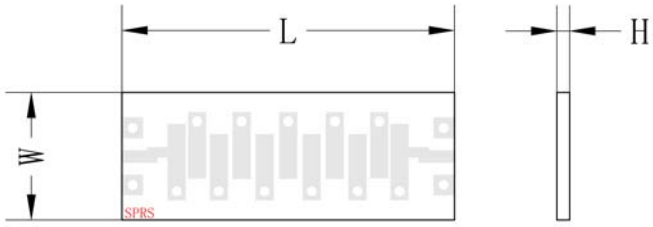
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	11.05	GHz
工作带宽	11.0-11.1	GHz
中心损耗	4.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	1.0	ns
带外抑制	40@DC-10.0GHz	dBc
带外抑制	40@12.0-28.0GHz	dBc

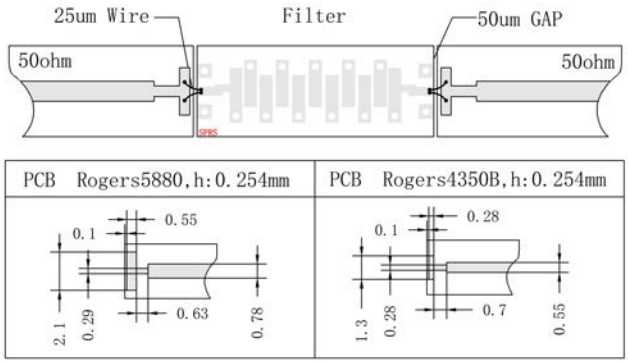
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.5，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



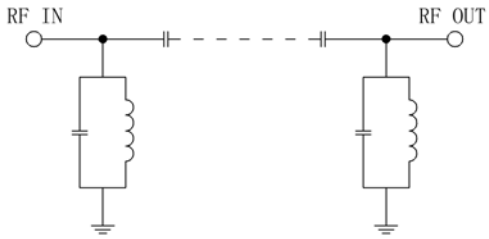
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

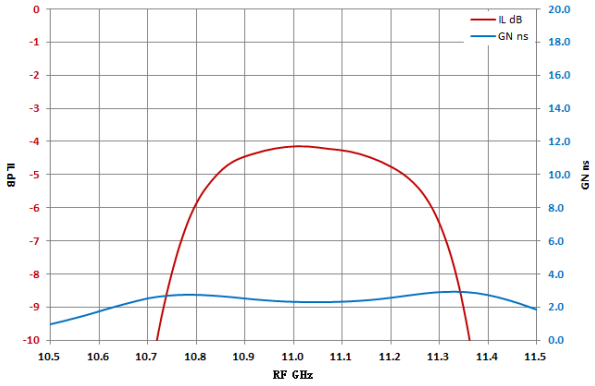
参考实物图

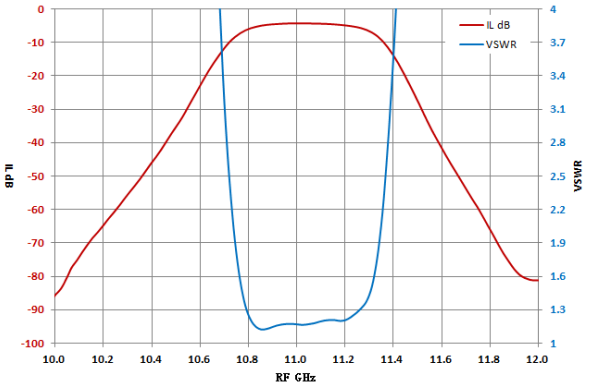


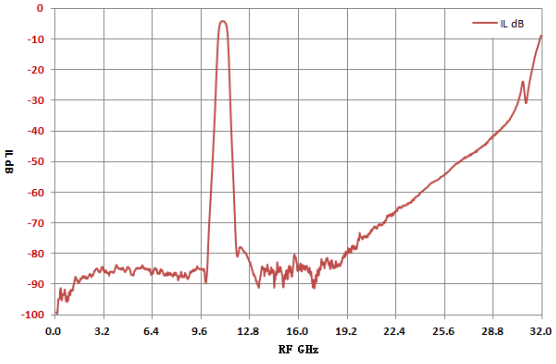
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

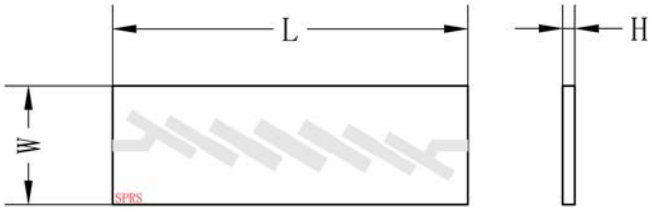
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	11.2	GHz
工作带宽	10.9-11.5	GHz
中心损耗	3.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-9.6GHz	dBc
带外抑制	40@12.6-22.0GHz	dBc

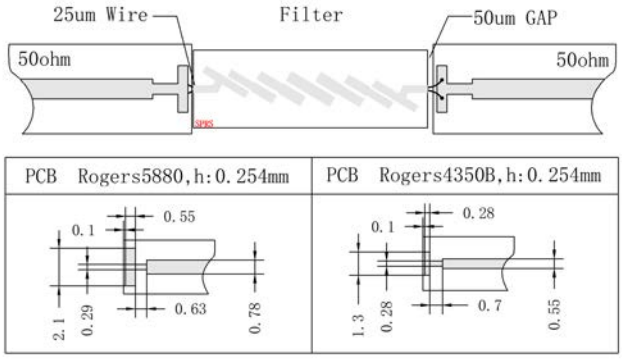
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



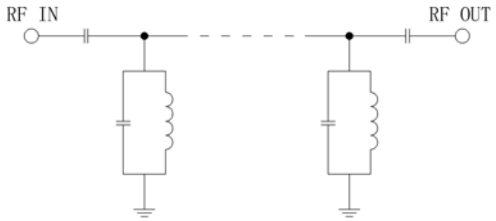
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

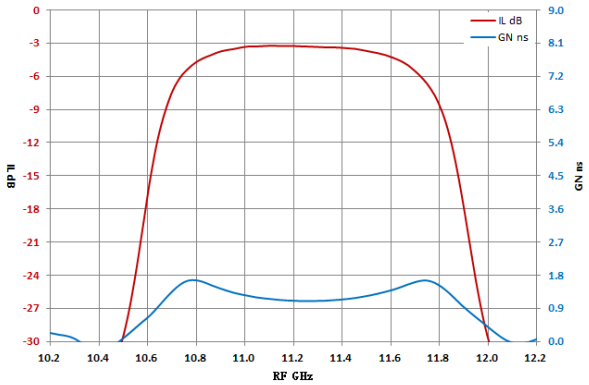
参考实物图

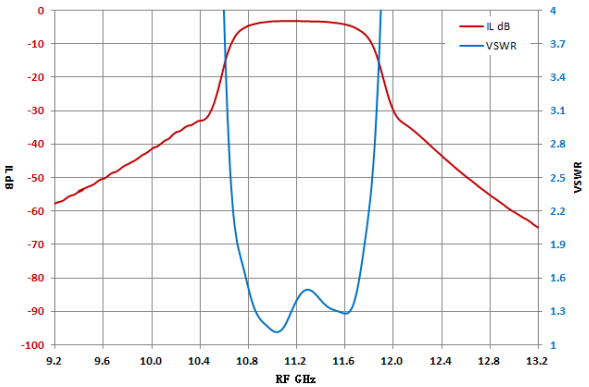


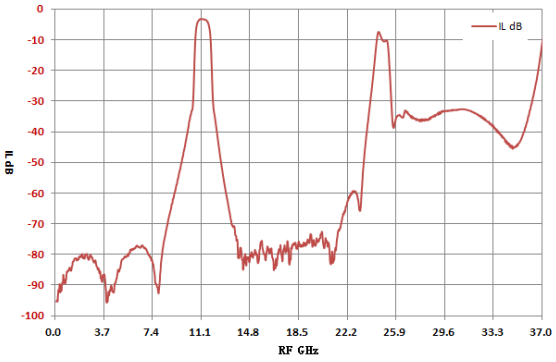
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



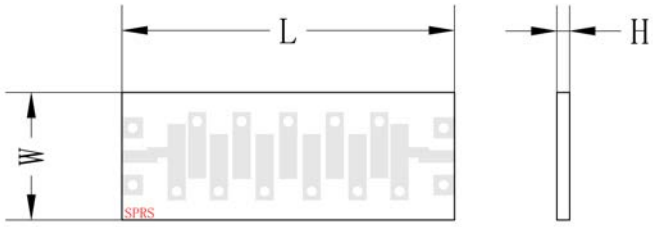
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	11.7	GHz
工作带宽	11.0-12.4	GHz
中心损耗	3.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-9.8GHz	dBc
带外抑制	40@13.7-25.0GHz	dBc

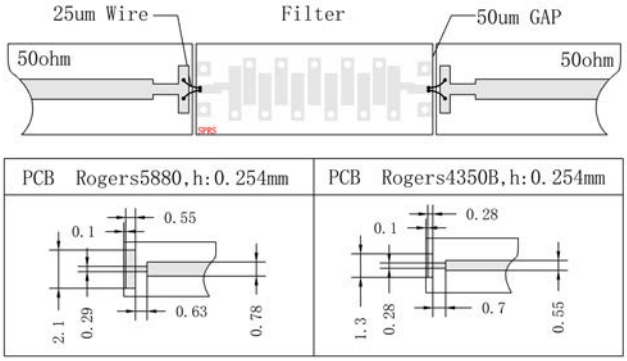
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



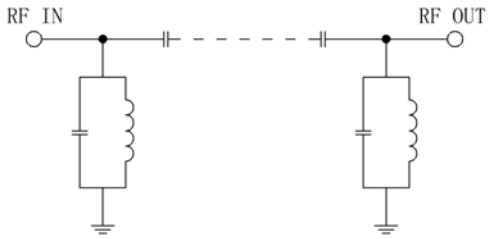
推荐装配图



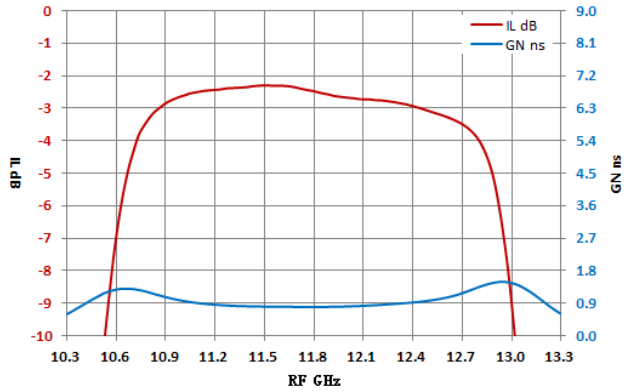
注意事项

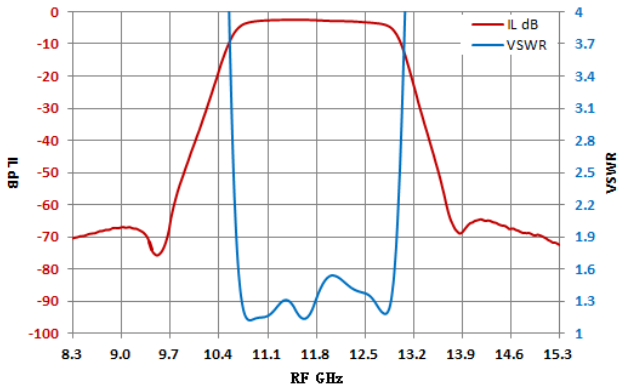
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

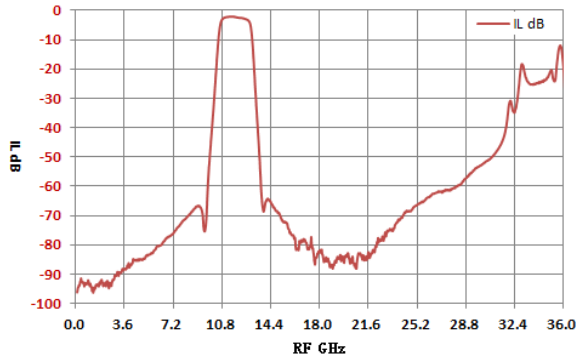
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

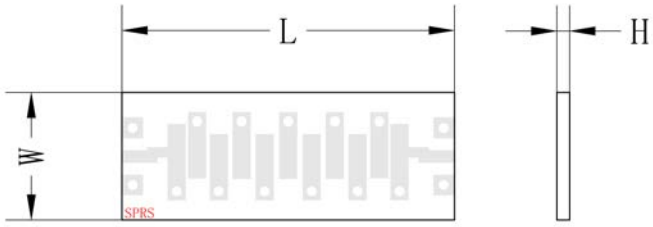
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	12.9	GHz
工作带宽	11.0-14.8	GHz
中心损耗	1.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-8.9GHz	dBc
带外抑制	40@17.0-30.0GHz	dBc

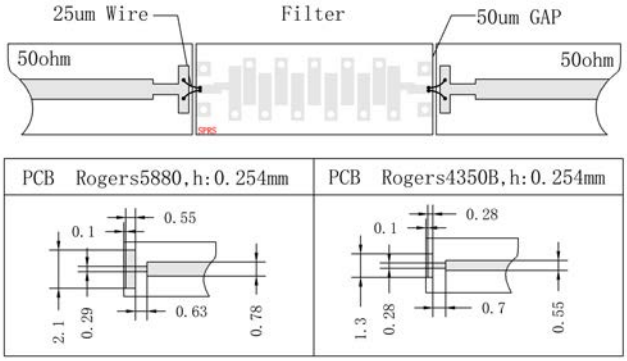
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.7，W：2.8，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



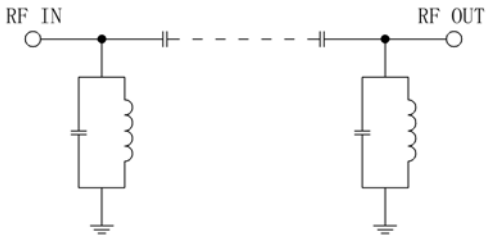
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

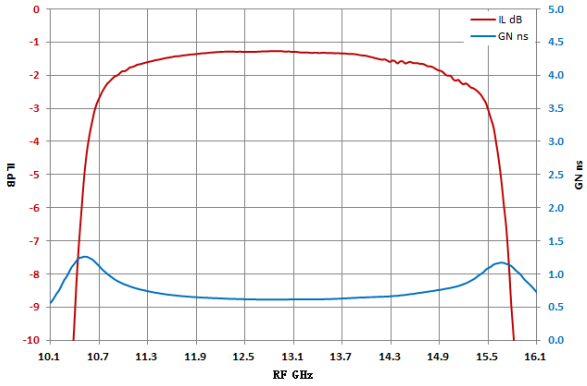
参考实物图

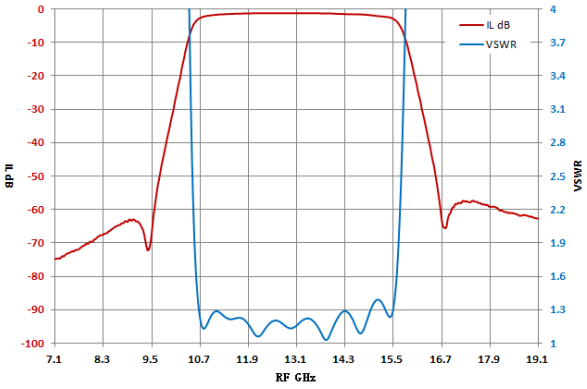


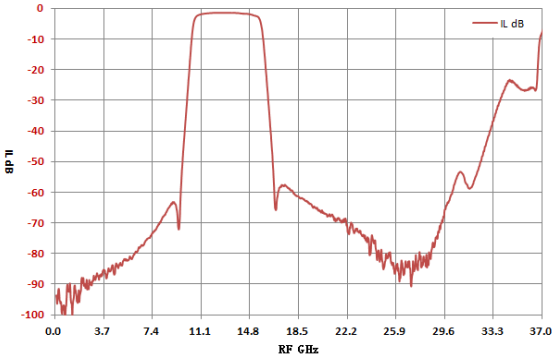
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

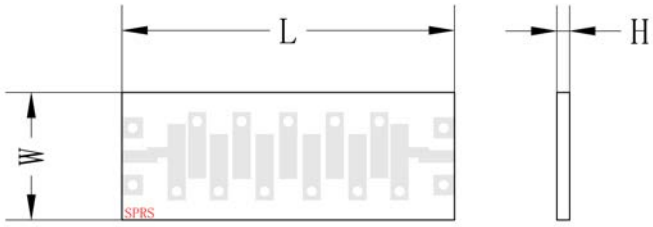
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	13	GHz
工作带宽	11.0-15.0	GHz
中心损耗	1.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-9.4GHz	dBc
带外抑制	40@16.8-33.0GHz	dBc

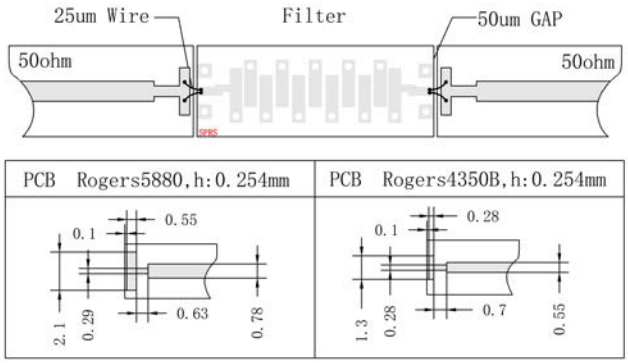
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.7，W：2.8，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



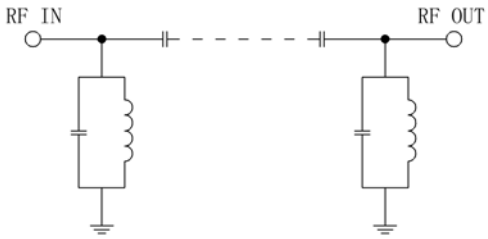
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

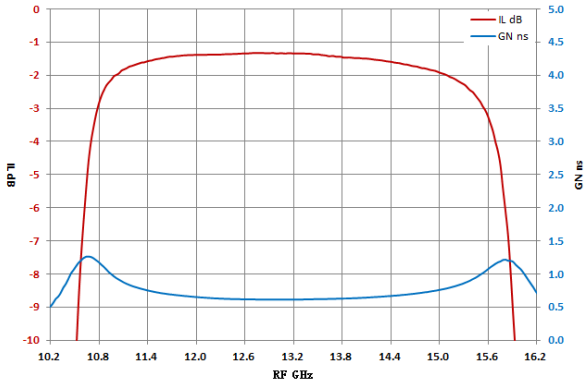
参考实物图

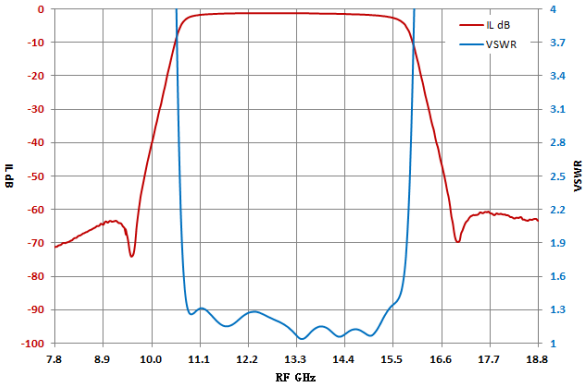


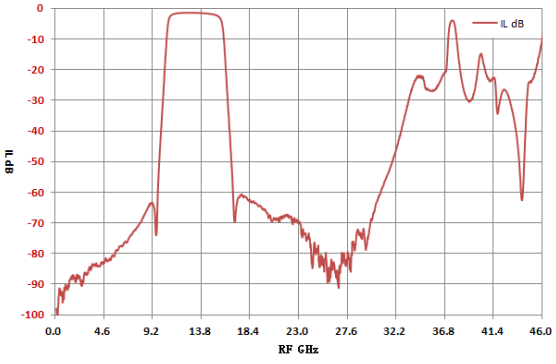
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

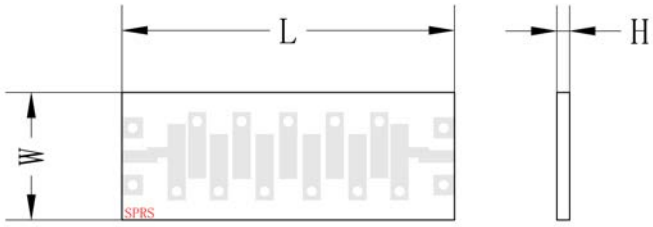
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	13.05	GHz
工作带宽	11.0-15.1	GHz
中心损耗	1.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-9.4GHz	dBc
带外抑制	40@16.8-32.0GHz	dBc

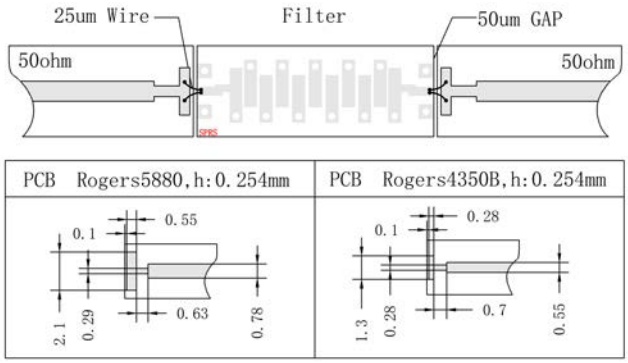
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：2.8，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



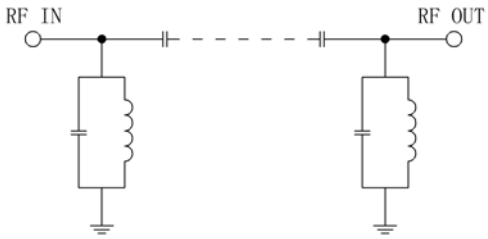
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

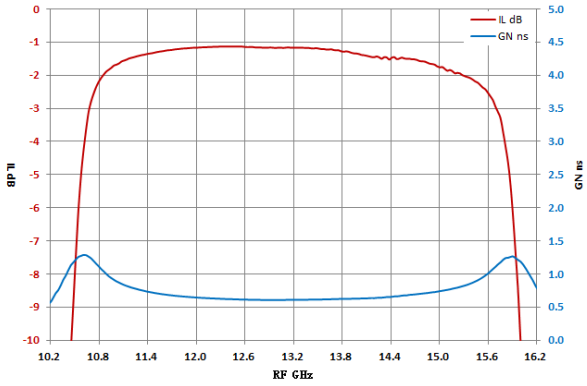
参考实物图

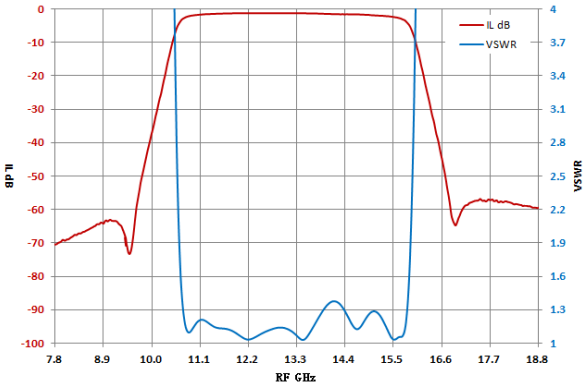


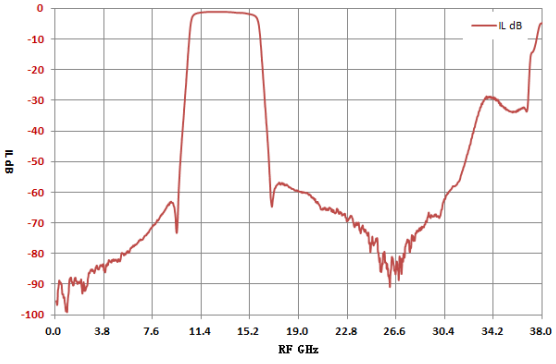
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

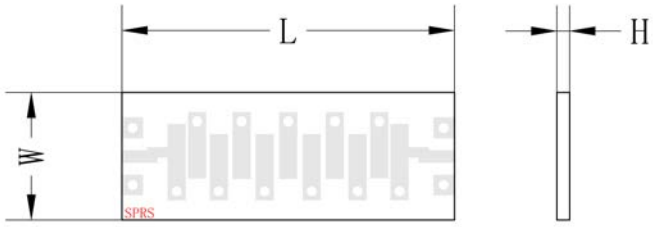
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	11.3	GHz
工作带宽	11.2-11.4	GHz
中心损耗	5.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-10.7GHz	dBc
带外抑制	40@11.9-28.0GHz	dBc

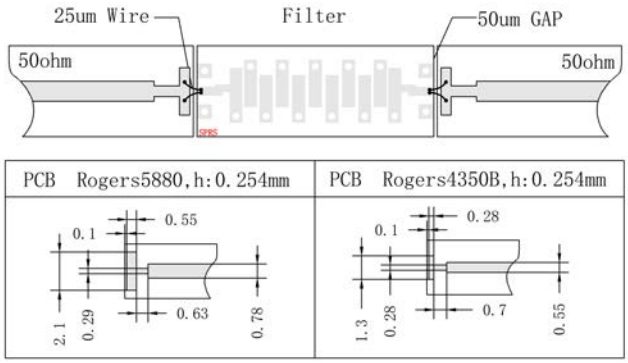
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.5，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



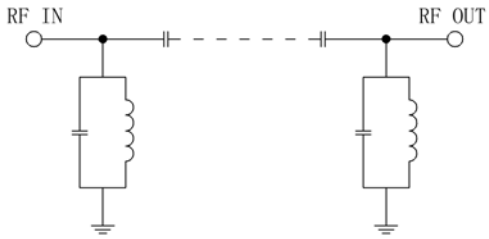
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

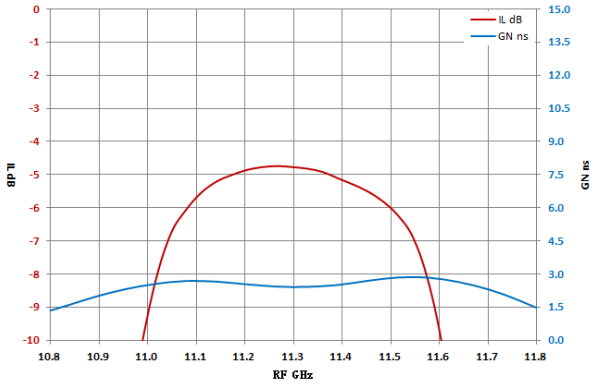
参考实物图

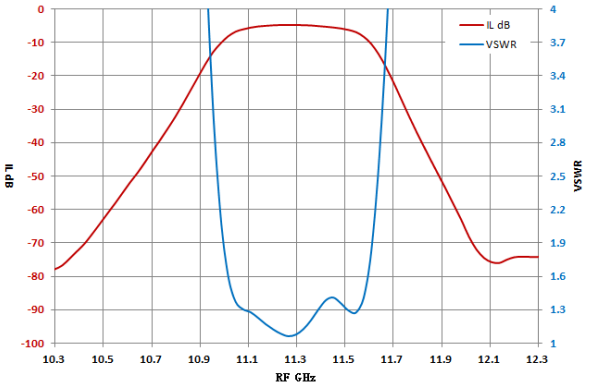


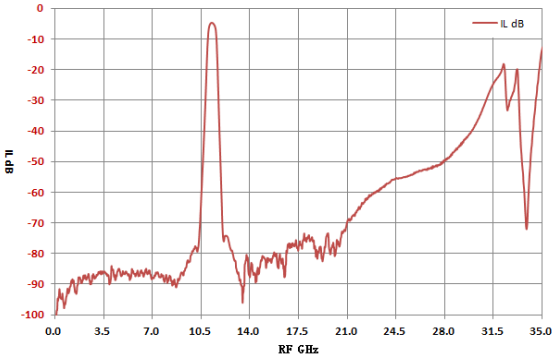
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



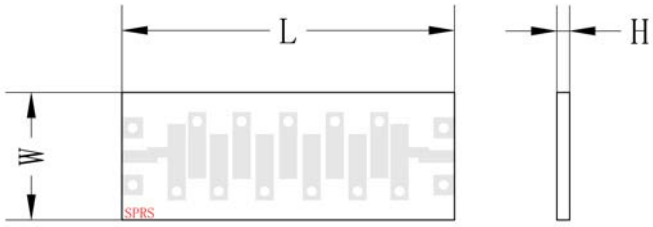
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	12.6	GHz
工作带宽	11.2-13.9	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-9.5GHz	dBc
带外抑制	35@15.3-30.0GHz	dBc

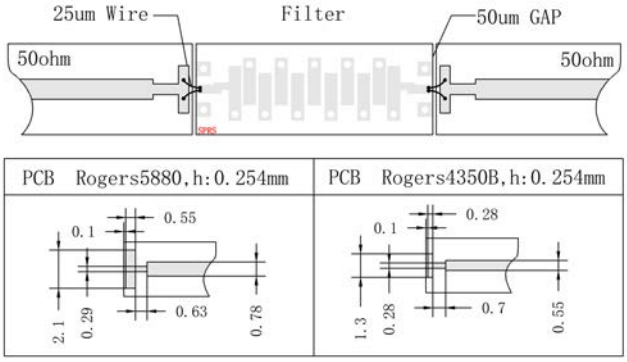
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



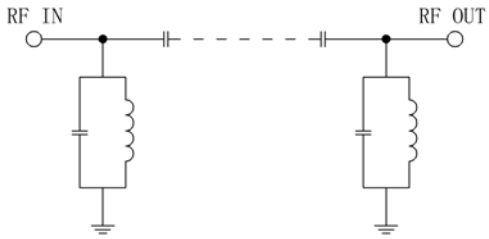
推荐装配图



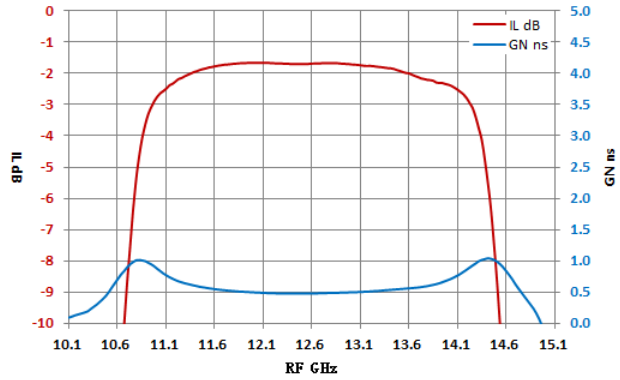
注意事项

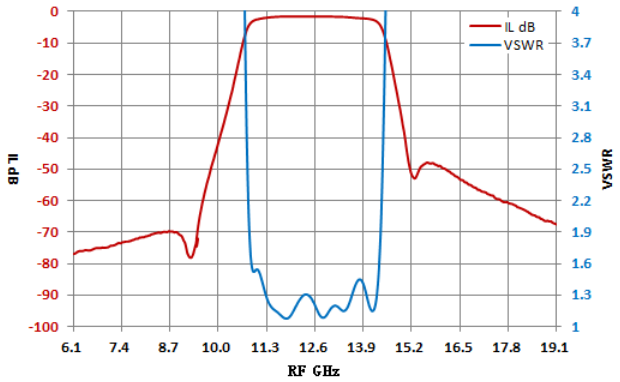
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

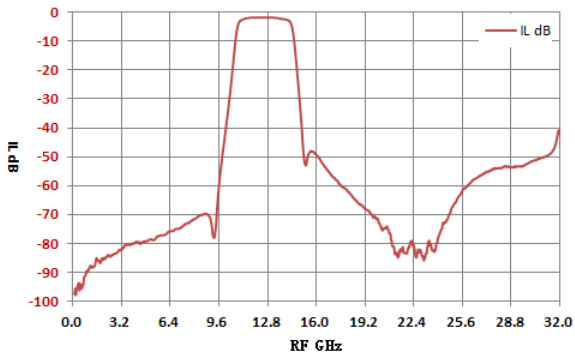
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

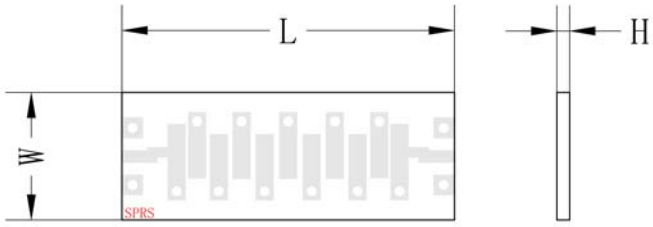
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	14.9	GHz
工作带宽	11.2-18.6	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-8.2GHz	dBc
带外抑制	40@21.8-36.0GHz	dBc

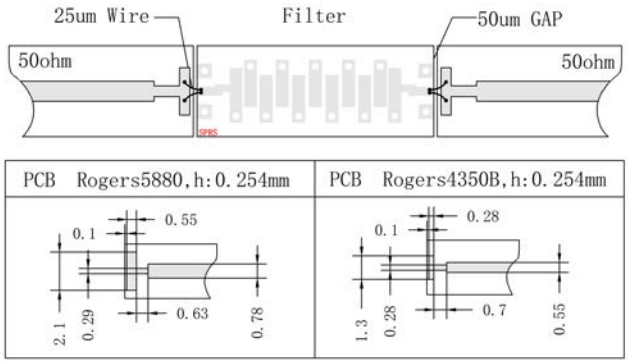
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



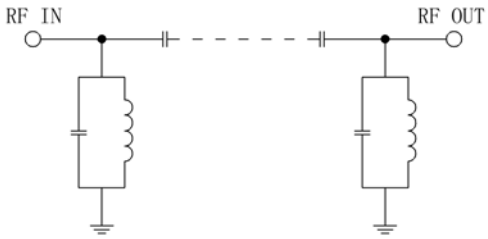
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.87mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

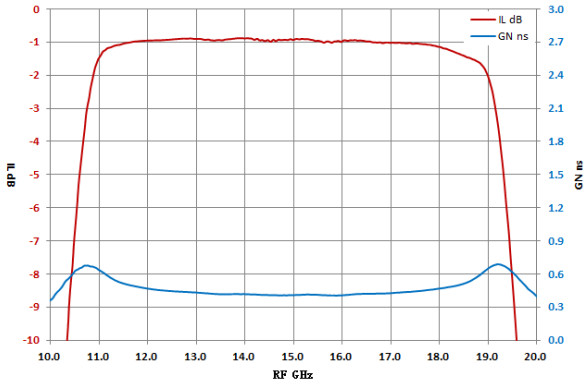
参考实物图

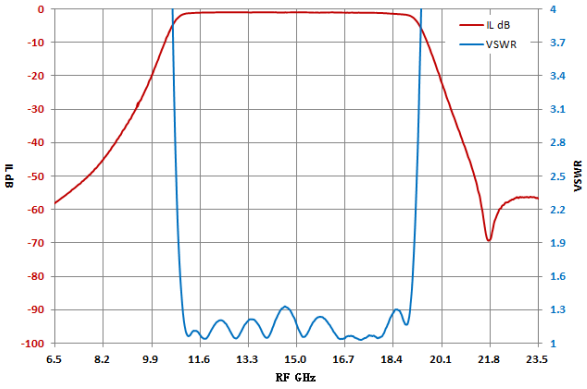


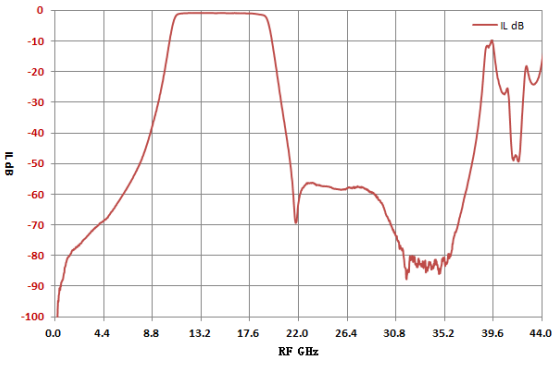
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



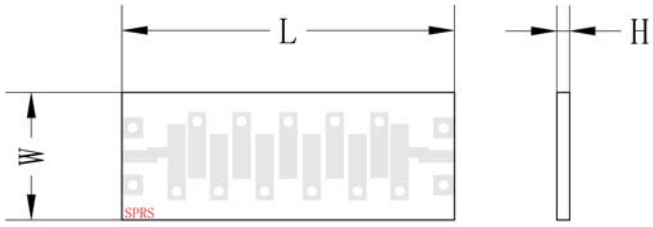
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	11.8	GHz
工作带宽	11.3-12.2	GHz
中心损耗	2.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-10.2GHz	dBc
带外抑制	40@14.2-19.5GHz	dBc

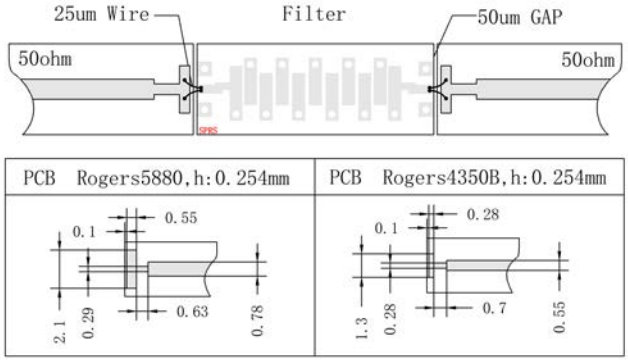
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：4.5，h：0.26

外形图：端口居中



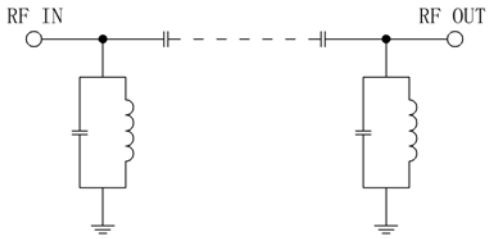
推荐装配图



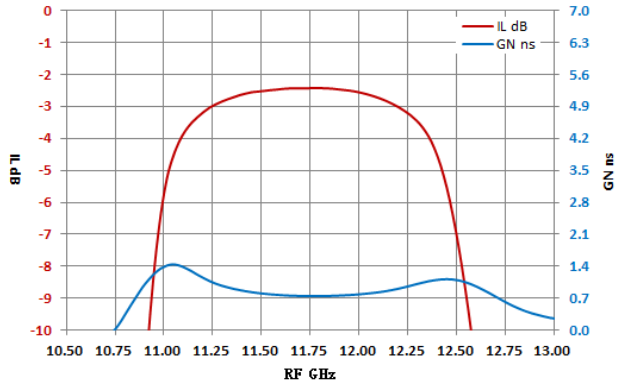
注意事项

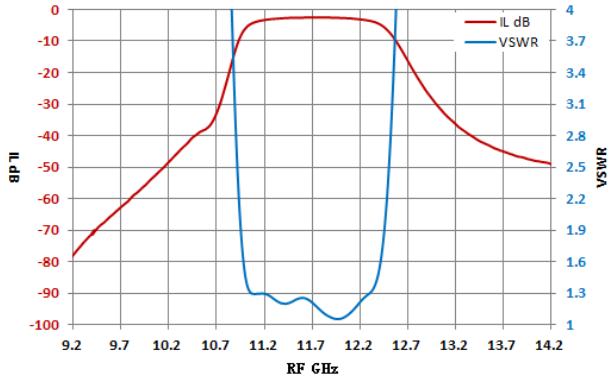
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

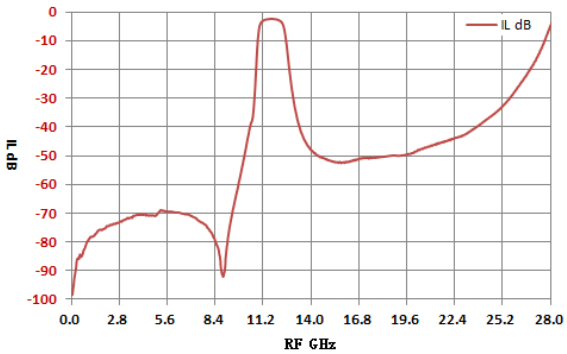
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



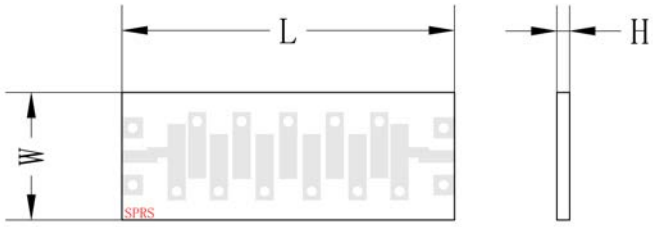
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	13.4	GHz
工作带宽	11.3-15.5	GHz
中心损耗	1.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-8.3GHz	dBc
带外抑制	35@17.2-35.0GHz	dBc

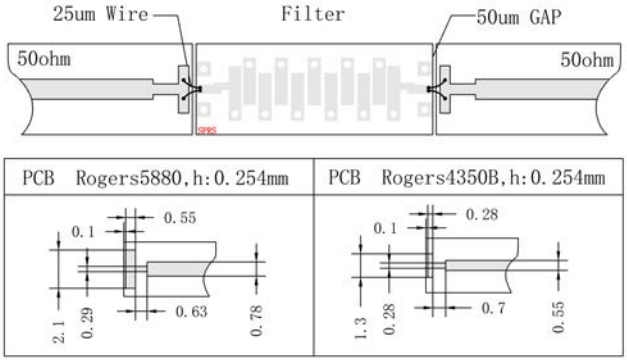
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



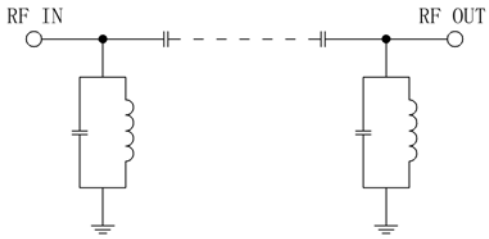
推荐装配图



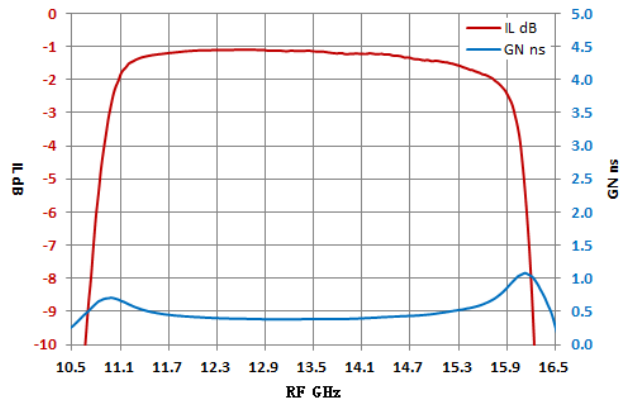
注意事项

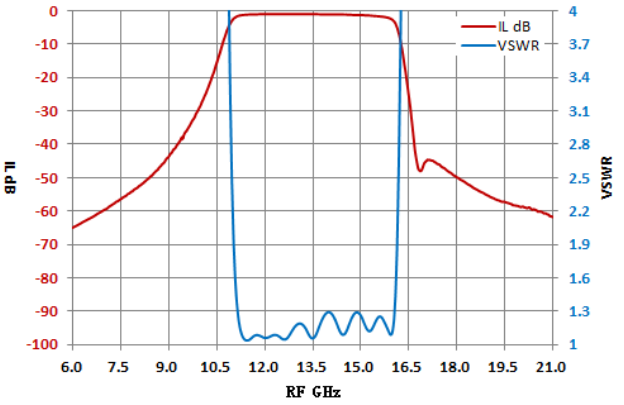
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

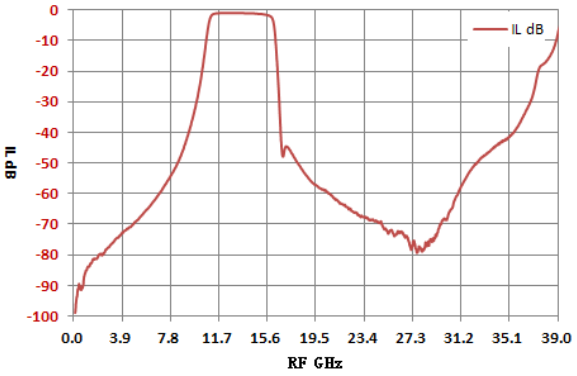
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

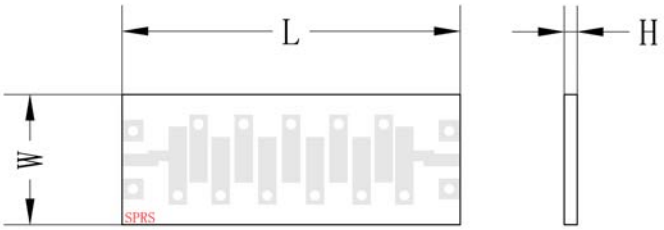
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	11.9	GHz
工作带宽	11.45-12.35	GHz
中心损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.6	ns
带外抑制	40@DC-10.4GHz	dBc
带外抑制	40@13.1-29.0GHz	dBc

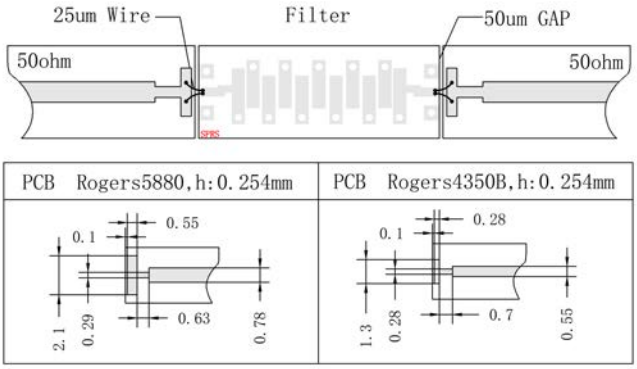
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：9.0，W：3.0，h：0.39

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.61mm,端口可互换;

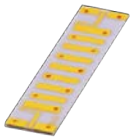
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

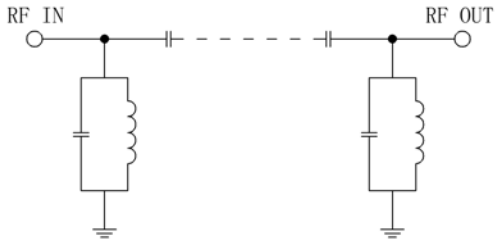
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

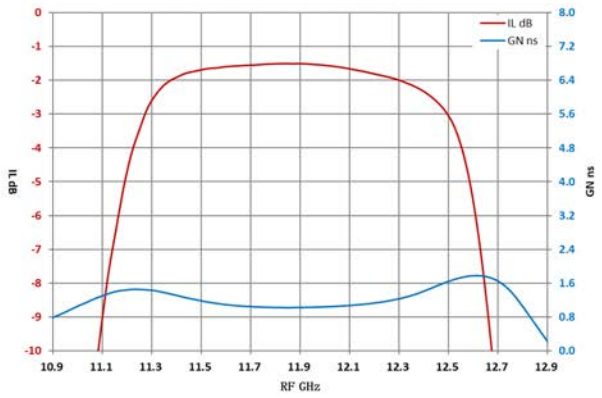
参考图

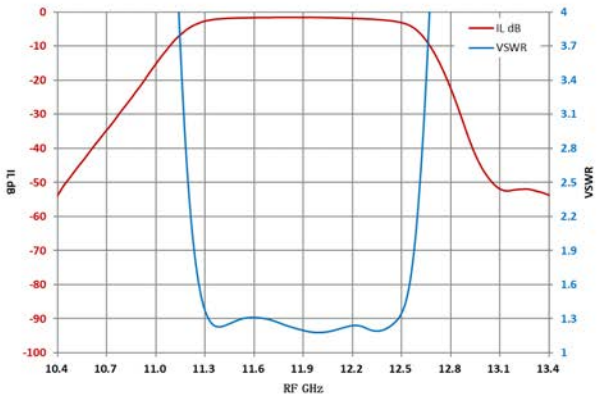


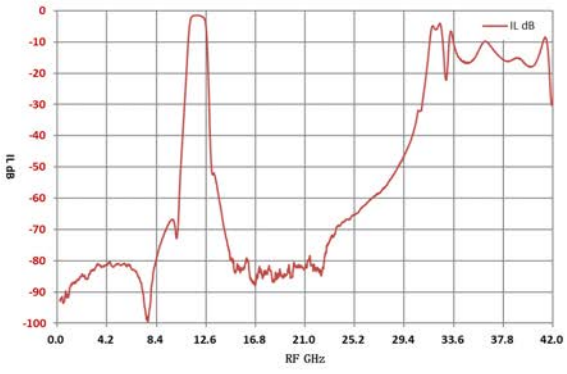
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



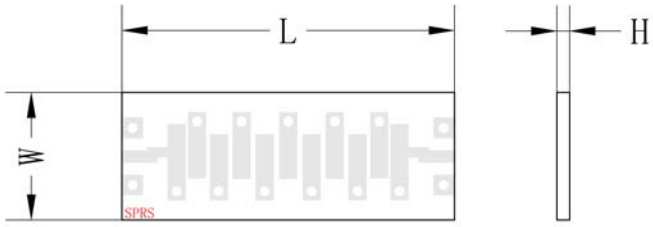
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	12.2	GHz
工作带宽	11.5-12.8	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-10.3GHz	dBc
带外抑制	40@14.2-24.0GHz	dBc

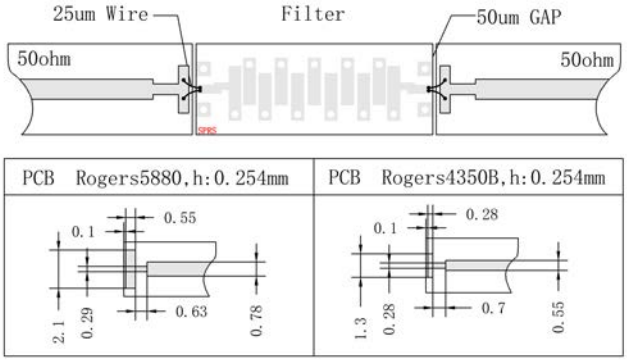
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



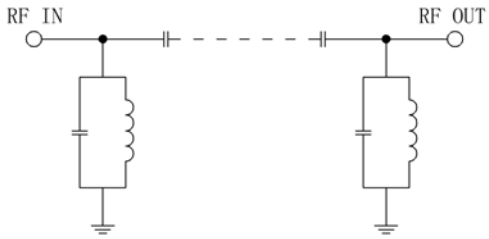
推荐装配图



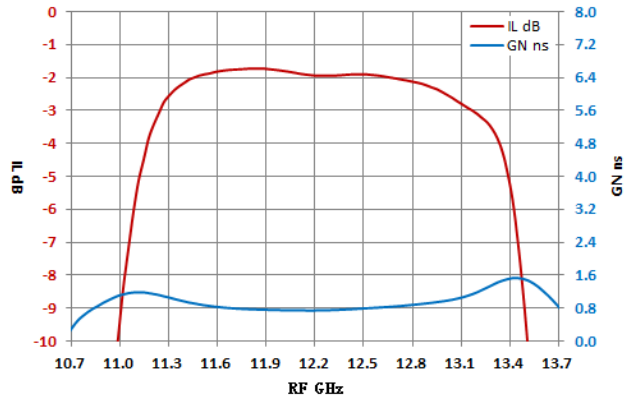
注意事项

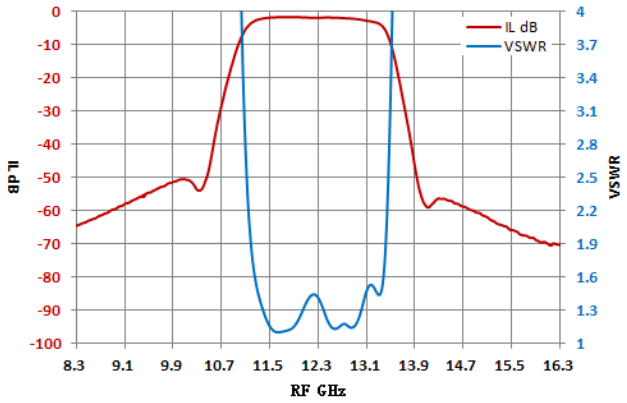
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

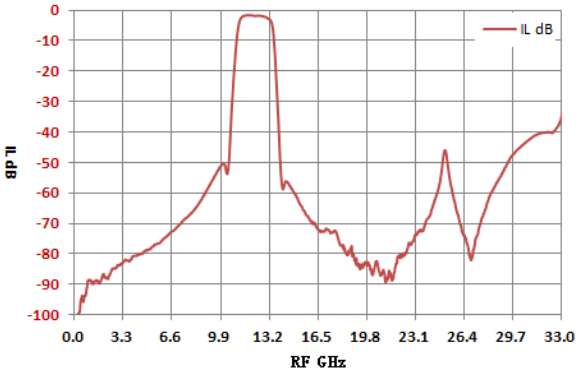
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

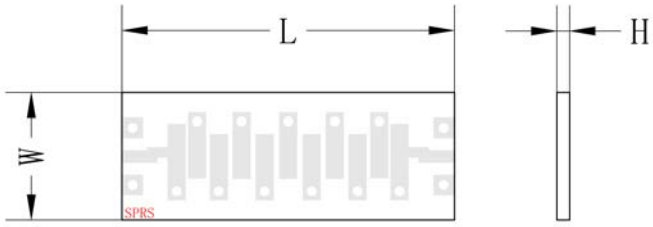
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	12.2	GHz
工作带宽	11.5-12.9	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-10.4GHz	dBc
带外抑制	40@14.1-29.0GHz	dBc

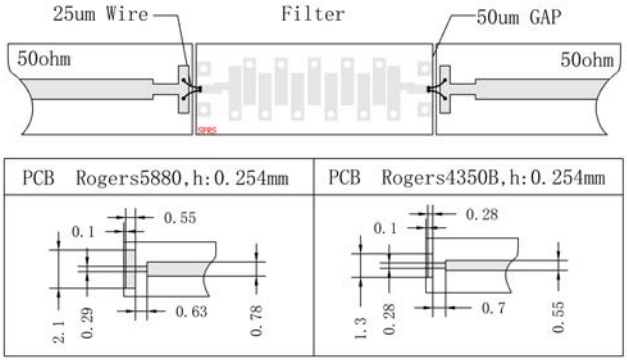
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.5，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



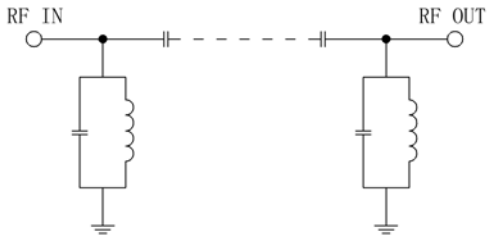
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

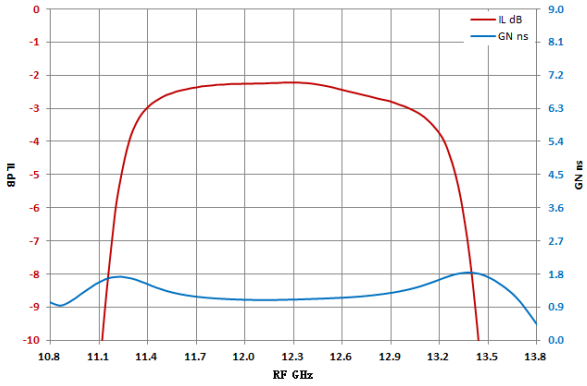
参考实物图

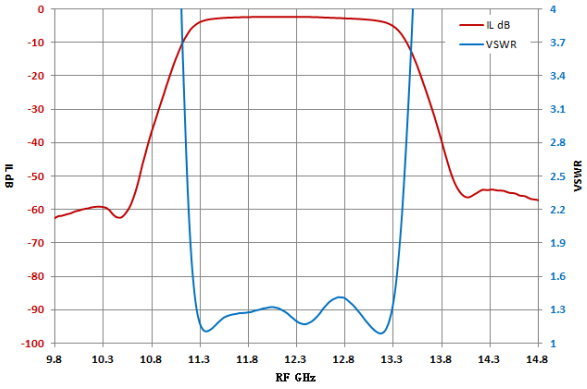


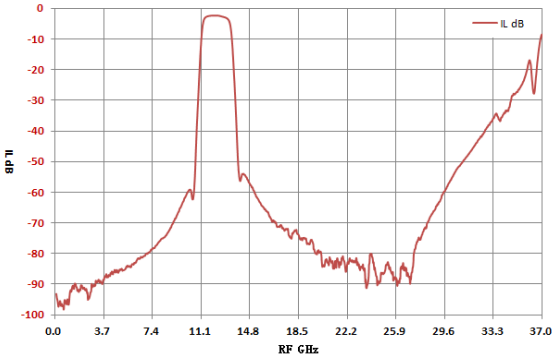
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

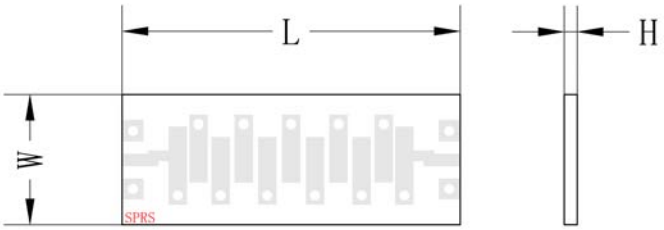
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	12.6	GHz
工作带宽	11.5-13.7	GHz
中心损耗	1.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.6	ns
带外抑制	35@DC-10.4GHz	dBc
带外抑制	50@15.4-25.0GHz	dBc

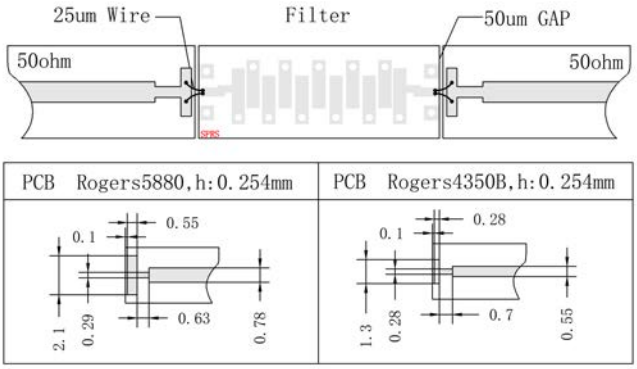
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：7.5，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

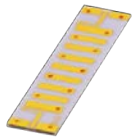
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

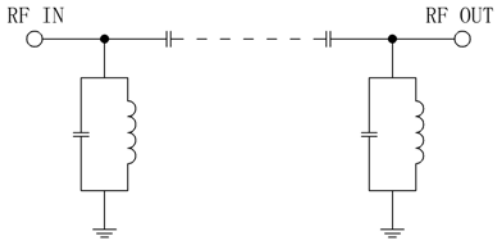
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

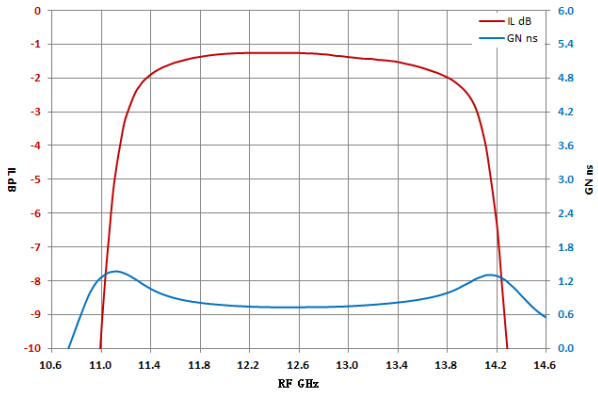
参考图

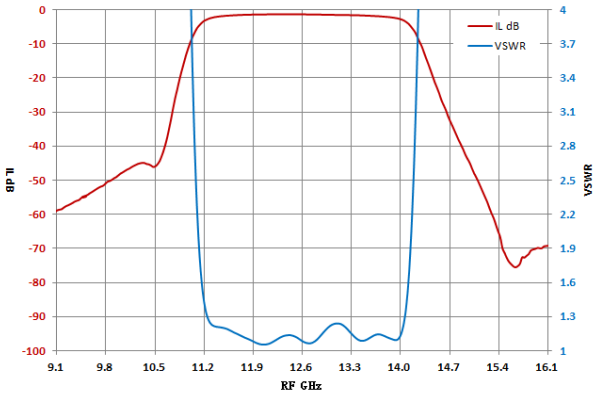


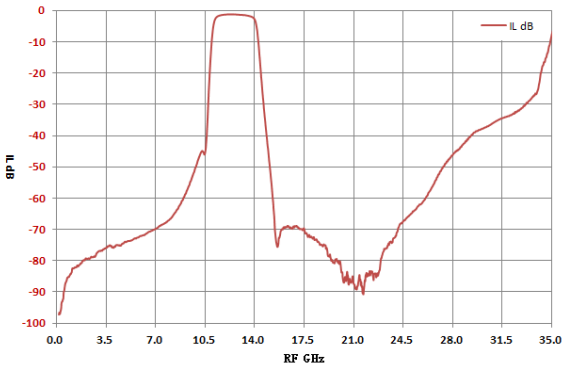
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



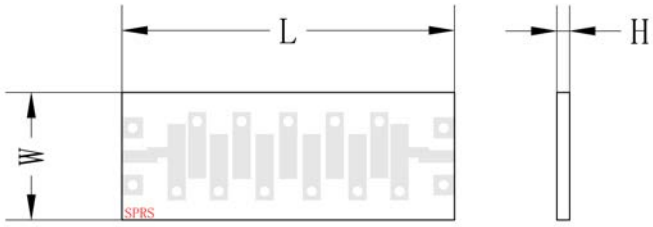
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	13.7	GHz
工作带宽	11.5-15.8	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-8.6GHz	dBc
带外抑制	40@17.6-30.0GHz	dBc

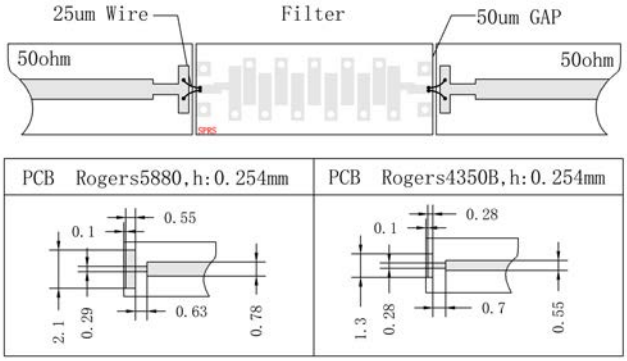
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



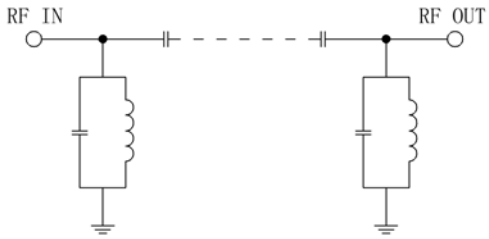
推荐装配图



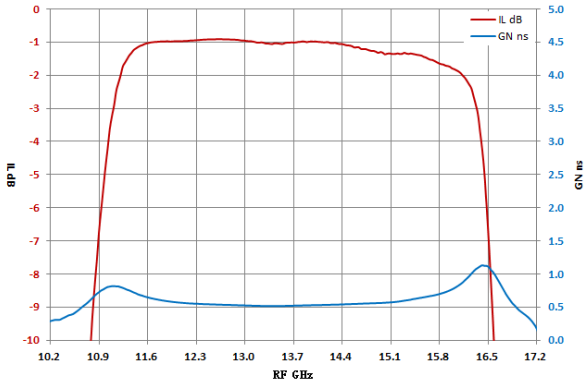
注意事项

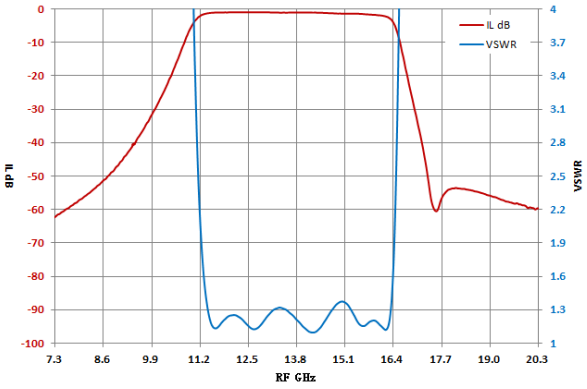
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

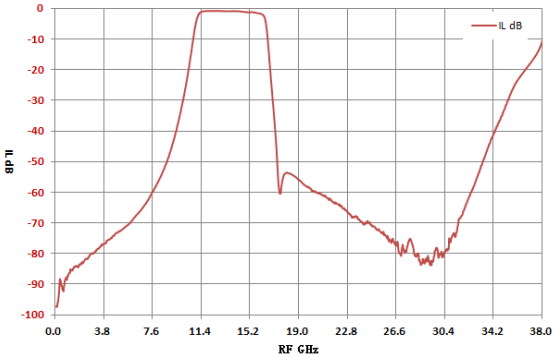
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

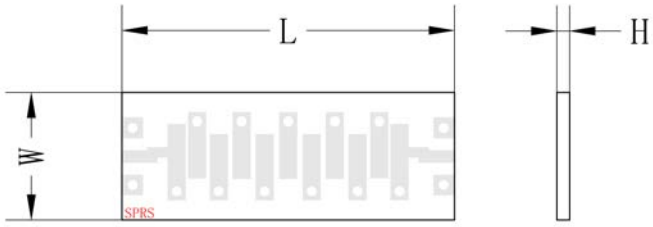
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	11.65	GHz
工作带宽	11.6-11.7	GHz
中心损耗	5.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	1.0	ns
带外抑制	40@DC-10.6GHz	dBc
带外抑制	40@12.4-29.0GHz	dBc

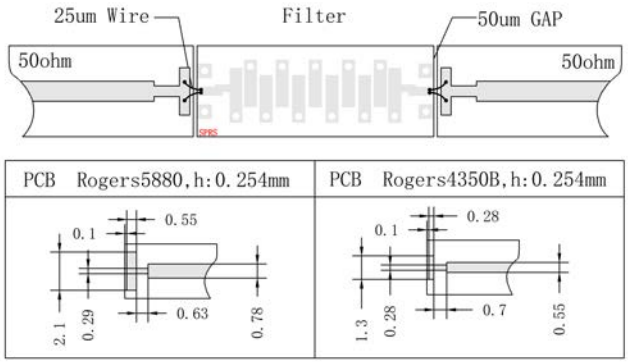
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.5，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



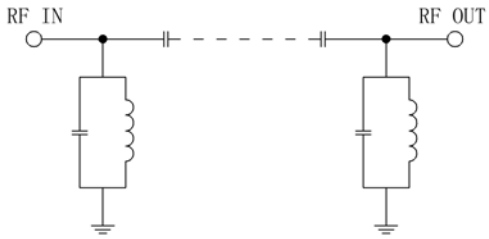
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

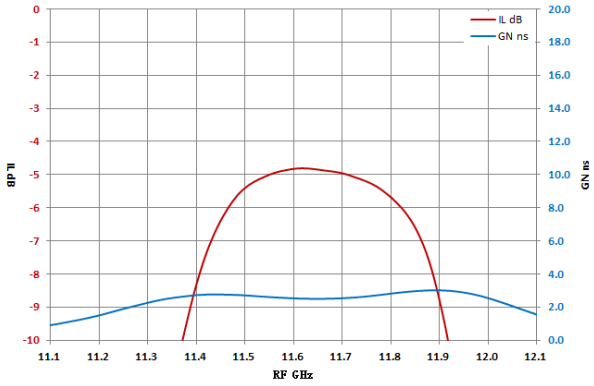
参考实物图

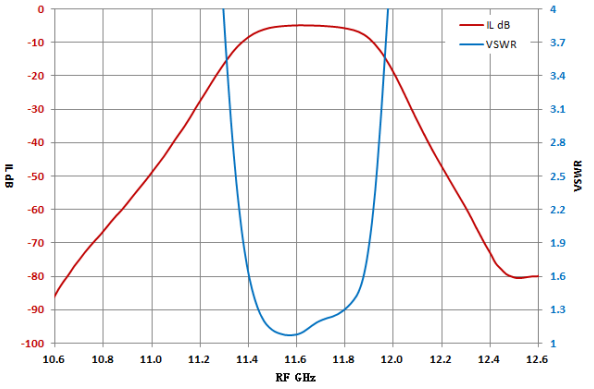


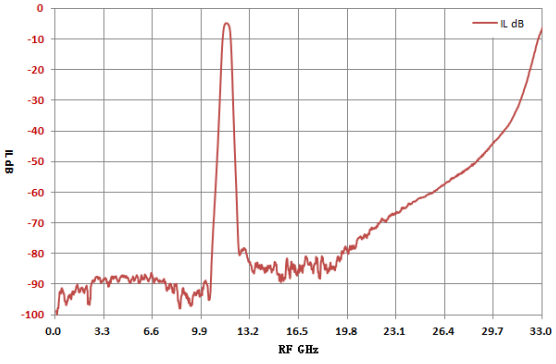
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

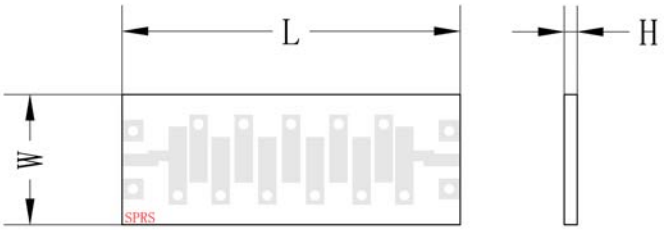
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	12.5	GHz
工作带宽	11.6-13.4	GHz
中心损耗	1.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-10.3GHz	dBc
带外抑制	60@15.2-29.0GHz	dBc

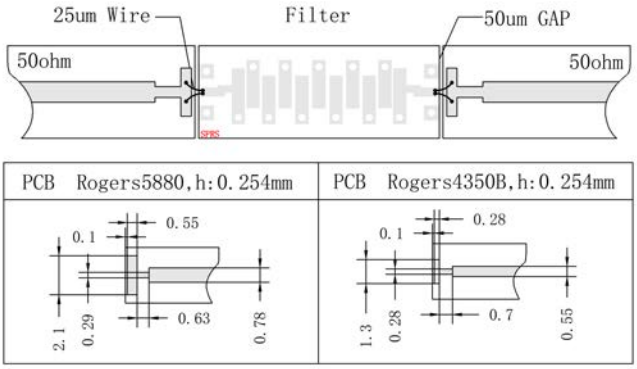
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

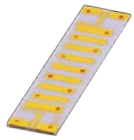
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

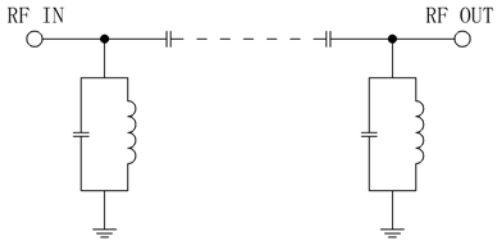
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

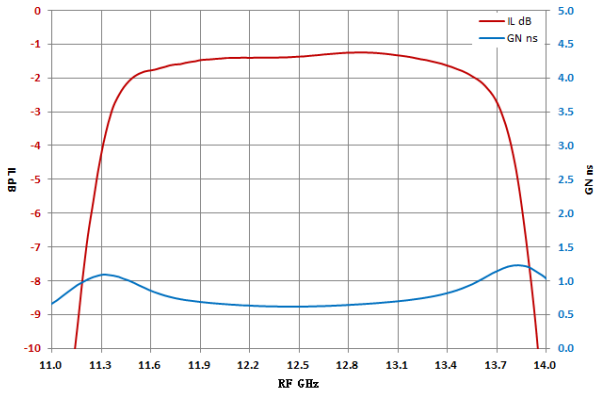
参考图

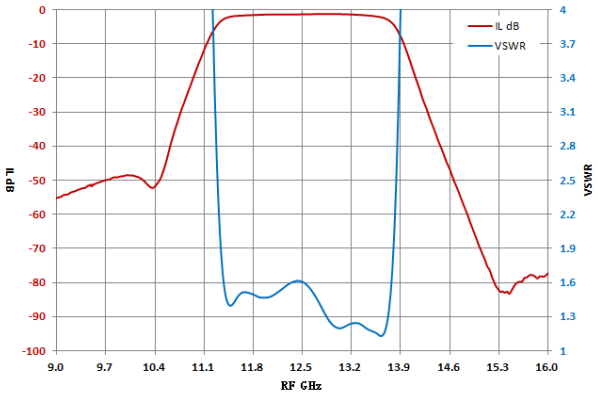


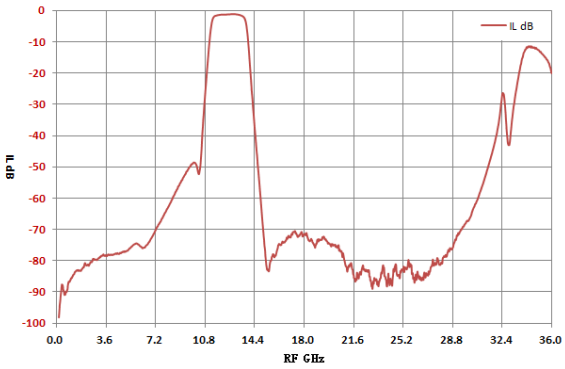
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



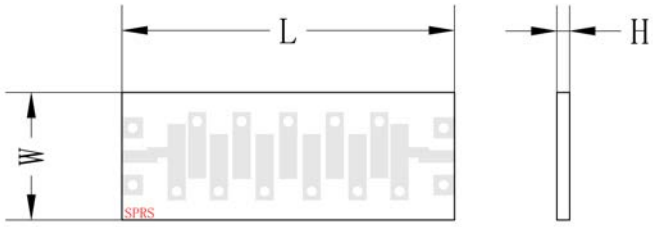
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	12.7	GHz
工作带宽	11.6-13.9	GHz
中心损耗	2.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-10.3GHz	dBc
带外抑制	40@15.3-27.0GHz	dBc

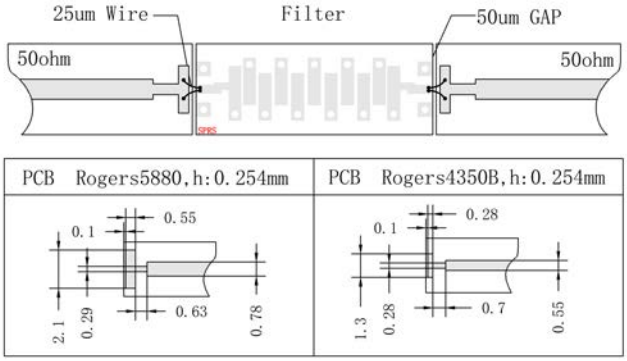
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：10.0，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



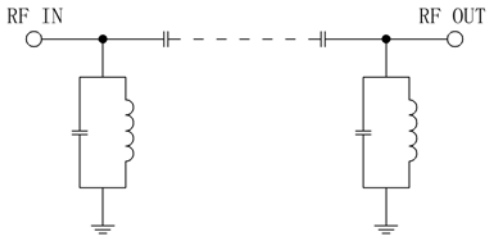
推荐装配图



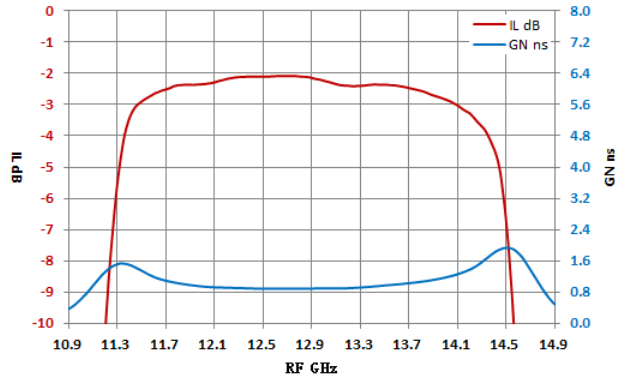
注意事项

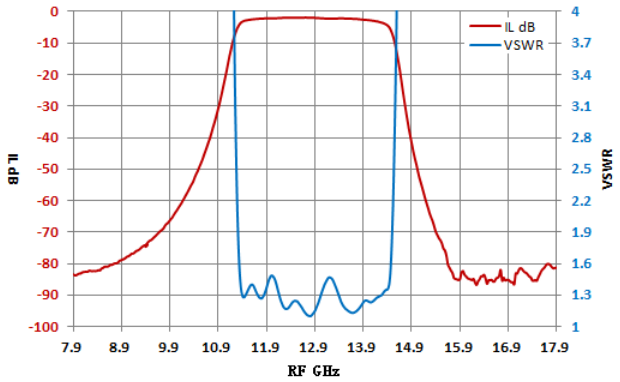
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

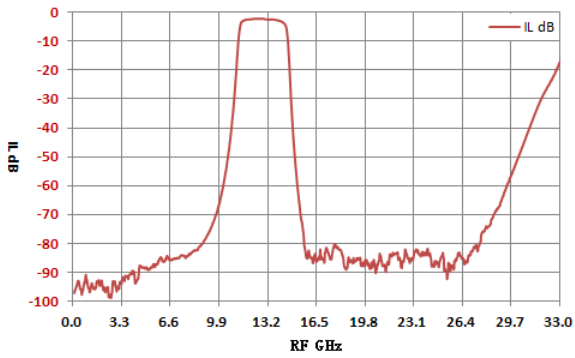
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



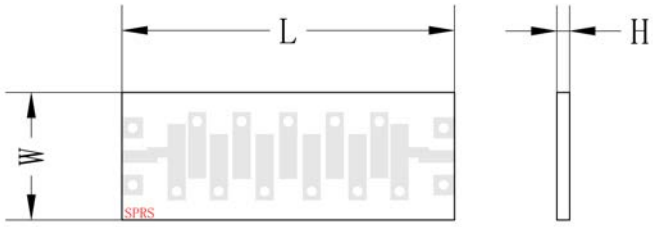
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	13.5	GHz
工作带宽	11.6-15.4	GHz
中心损耗	4.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-9.4GHz	dBc
带外抑制	35@17.8-35.0GHz	dBc

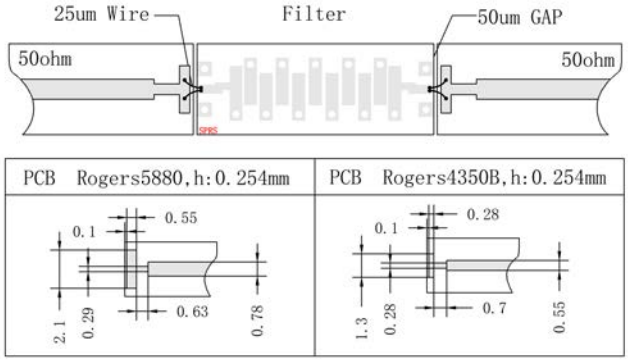
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



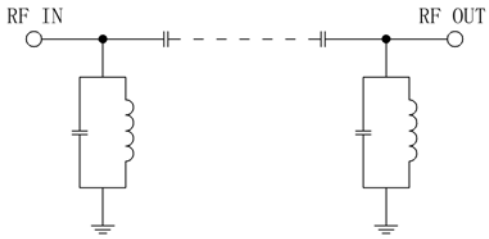
推荐装配图



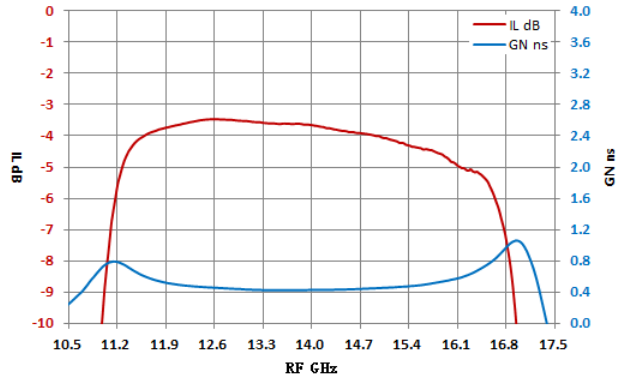
注意事项

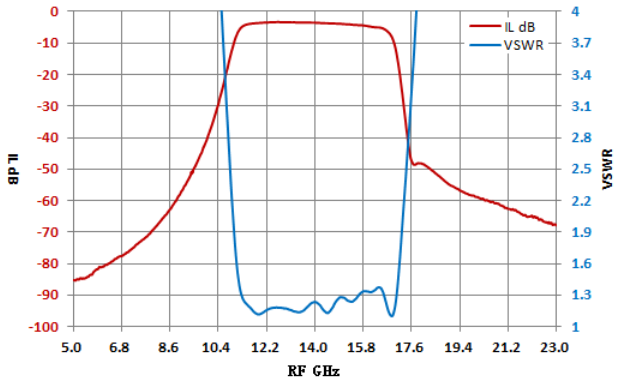
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

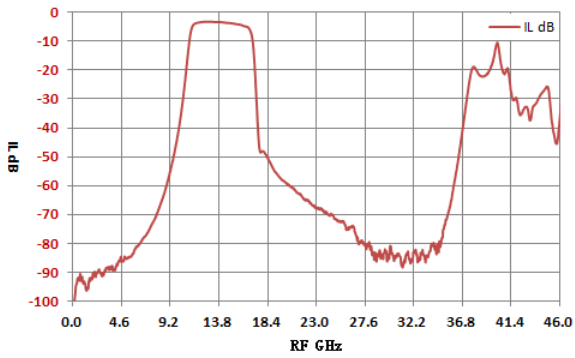
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



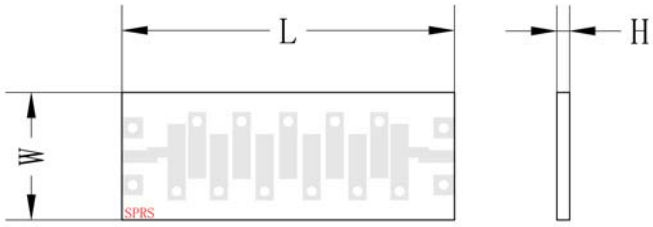
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	15.0	GHz
工作带宽	11.7-18.3	GHz
中心损耗	1.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-8.8GHz	dBc
带外抑制	40@21.4-36.0GHz	dBc

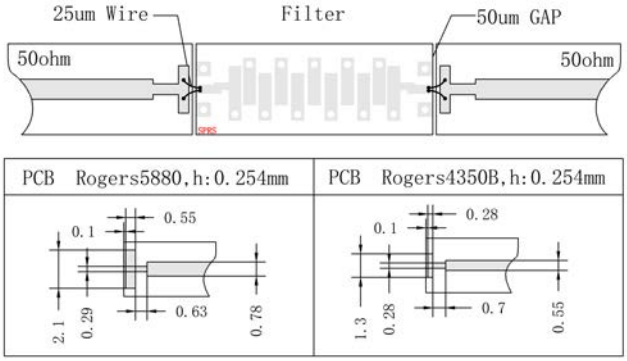
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



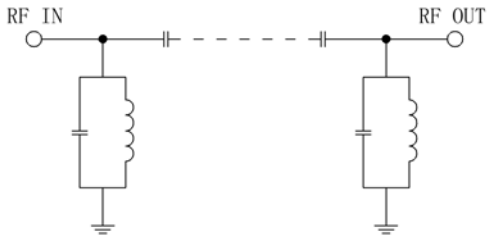
推荐装配图



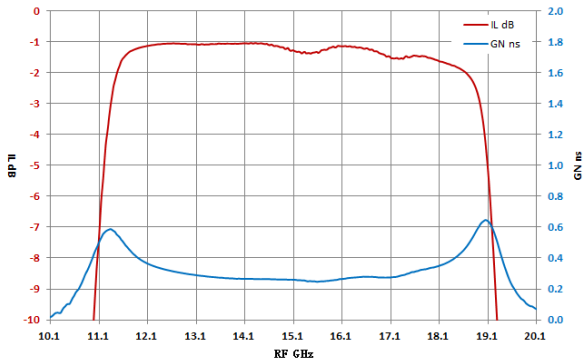
注意事项

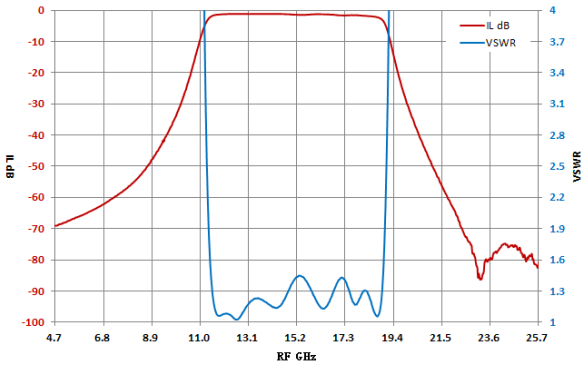
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

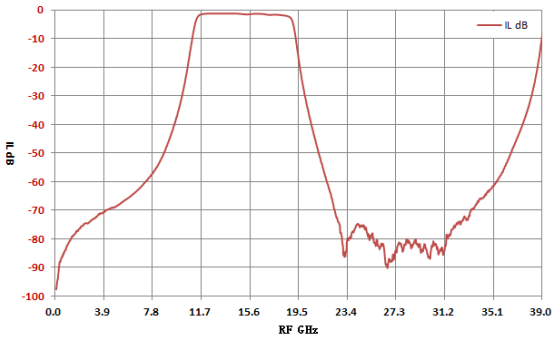
原理图



典型曲线







产品特点

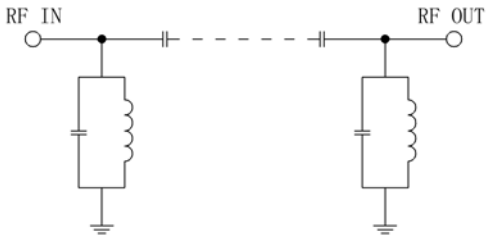
高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



技术要求

项目	参数	单位
中心频率	13.4	GHz
工作带宽	11.8-15.0	GHz
中心损耗	2.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-9.0GHz	dBc
带外抑制	35@16.5-30.4GHz	dBc

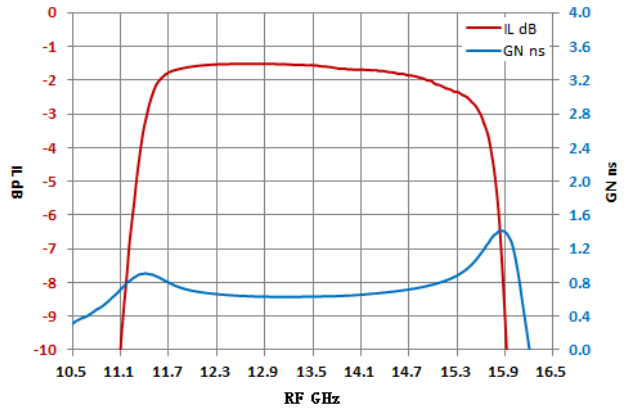
原理图

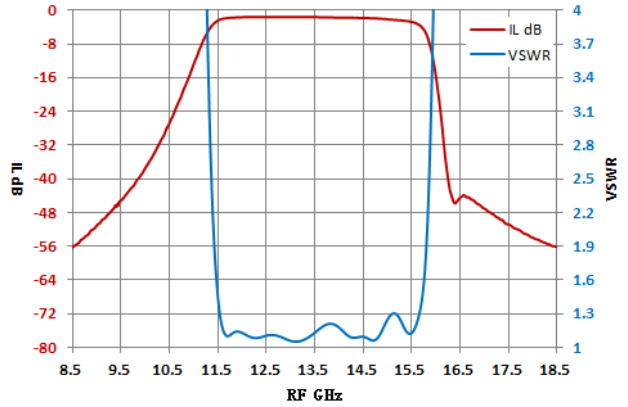


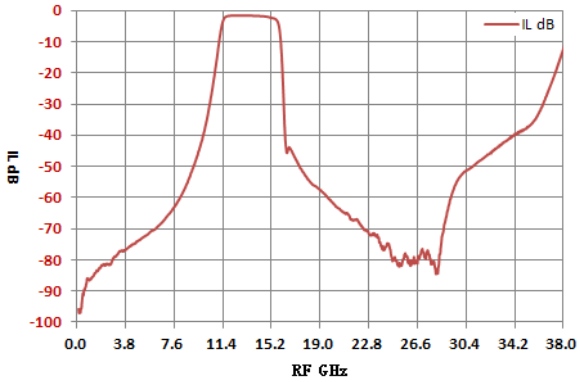
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：3.5，h：0.26

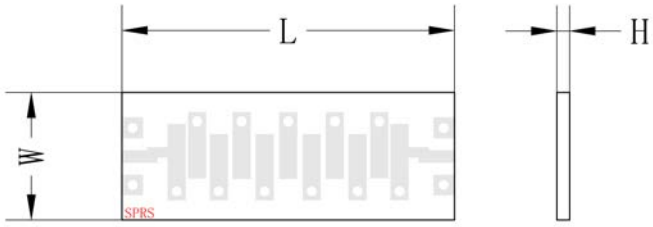
典型曲线



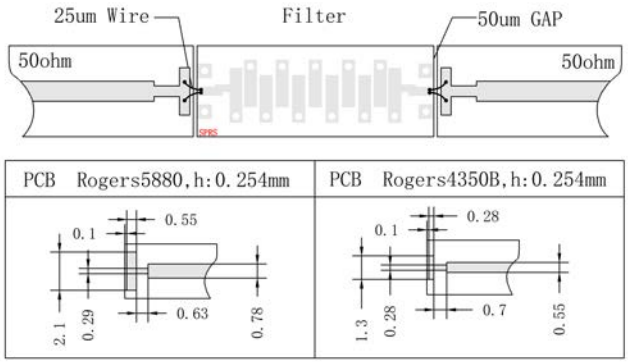




外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



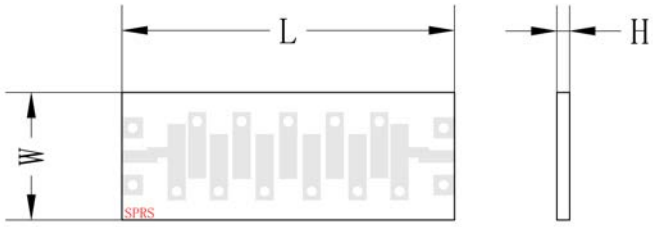
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	14.2	GHz
工作带宽	11.8-16.6	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-8.8GHz	dBc
带外抑制	30@18.2-37.0GHz	dBc

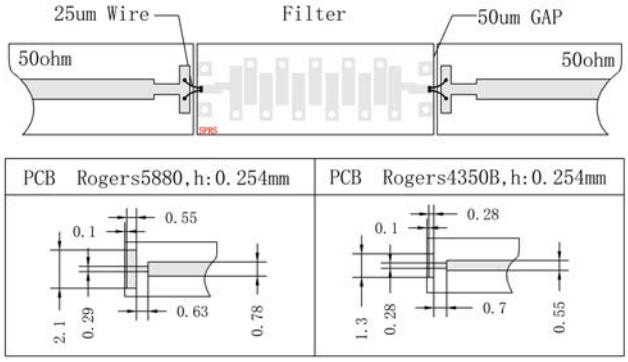
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



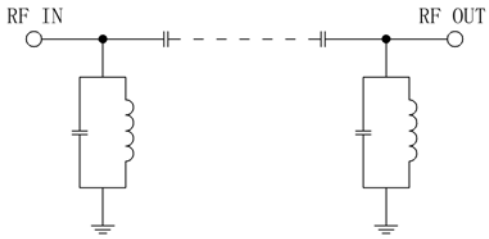
推荐装配图



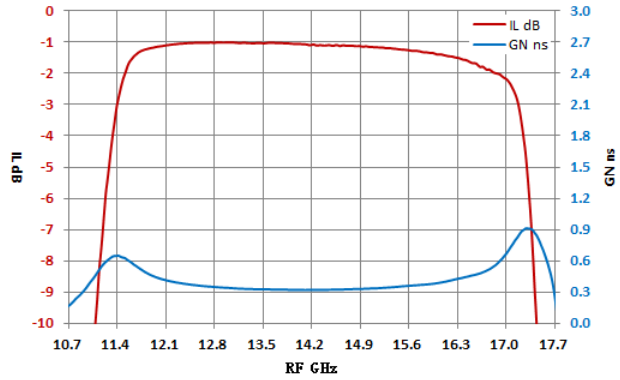
注意事项

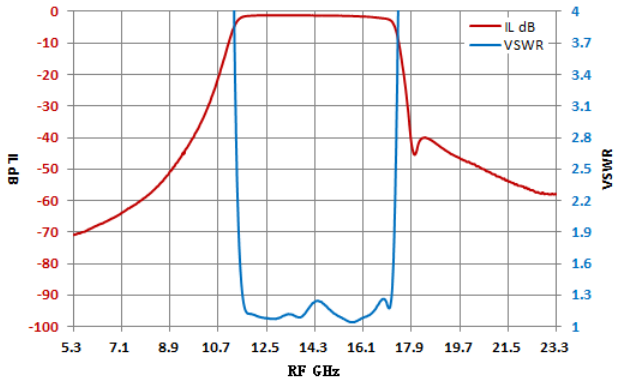
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

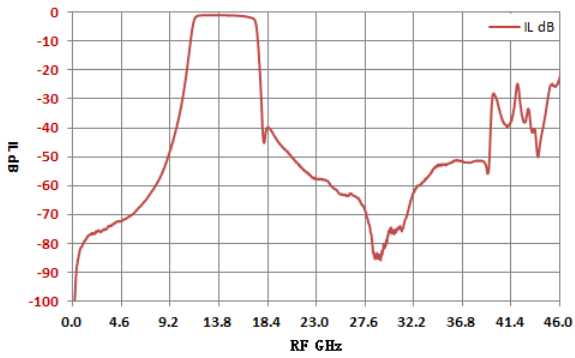
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

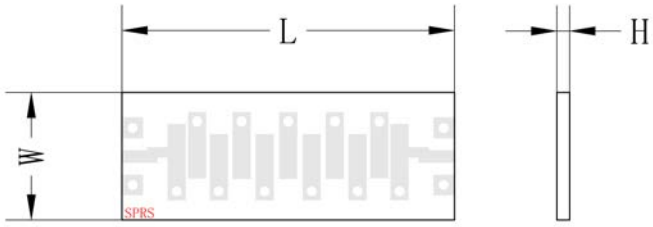
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	12.0	GHz
工作带宽	11.9-12.1	GHz
中心损耗	2.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	1.0	ns
带外抑制	40@DC-4.8GHz	dBc
带外抑制	40@10.2-18.0GHz	dBc

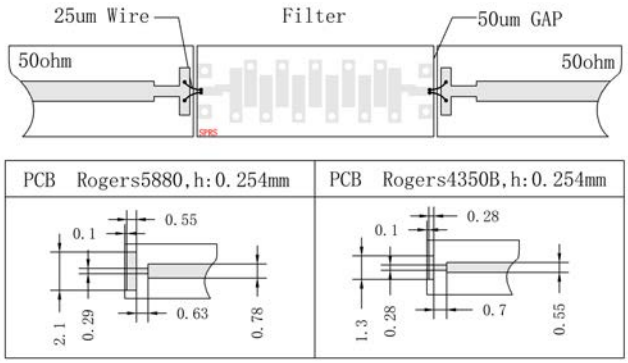
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.5，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



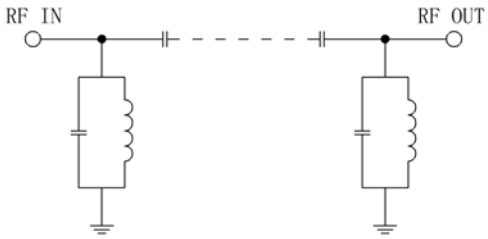
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

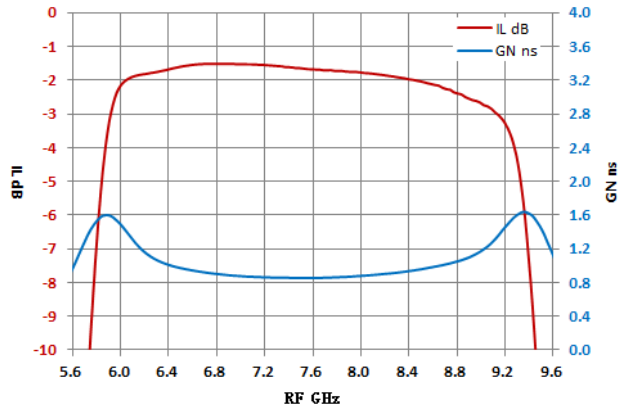
参考实物图

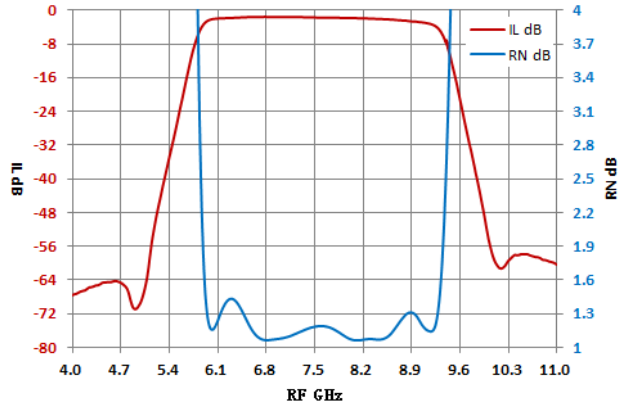


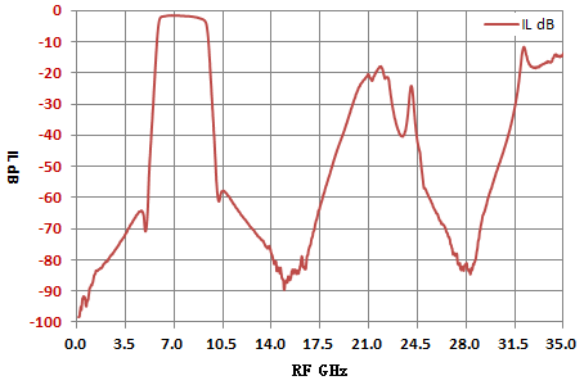
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

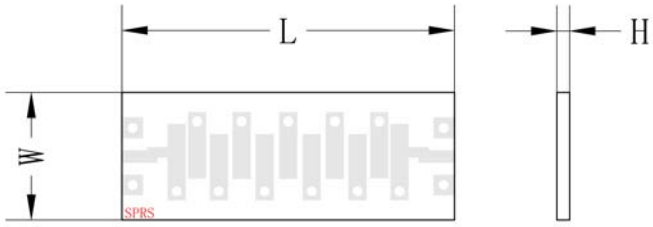
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	12.1	GHz
工作带宽	11.9-12.3	GHz
中心损耗	3.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-10.7GHz	dBc
带外抑制	40@14.0-30.0GHz	dBc

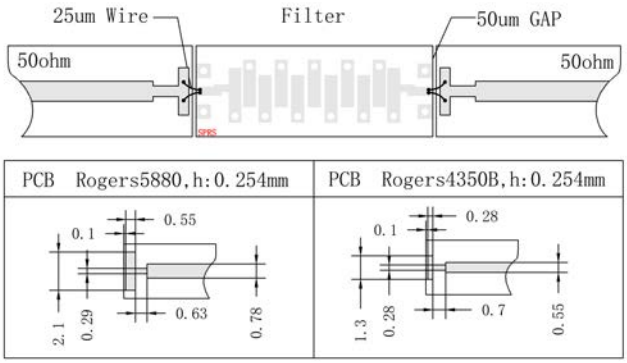
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



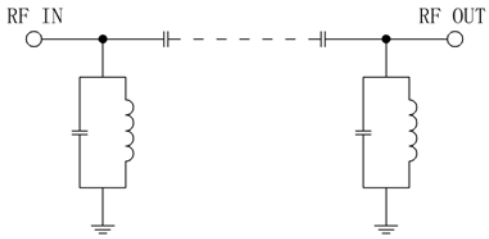
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

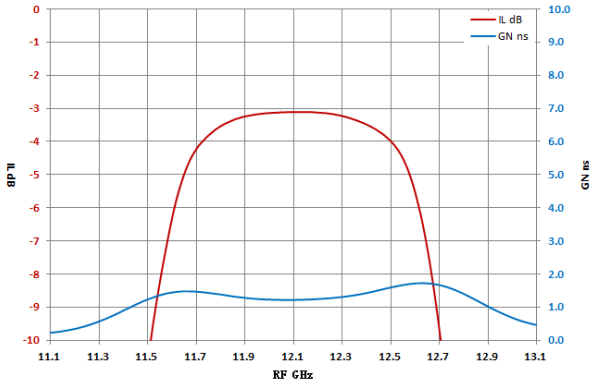
参考实物图

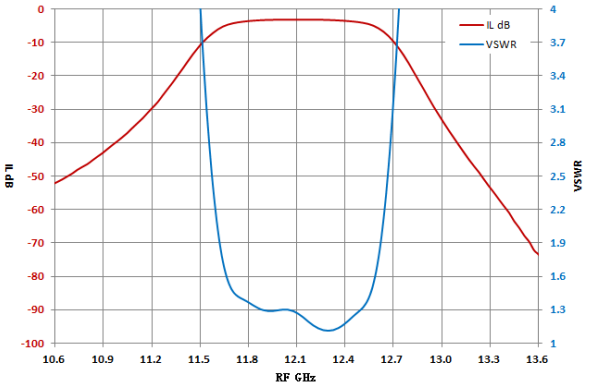


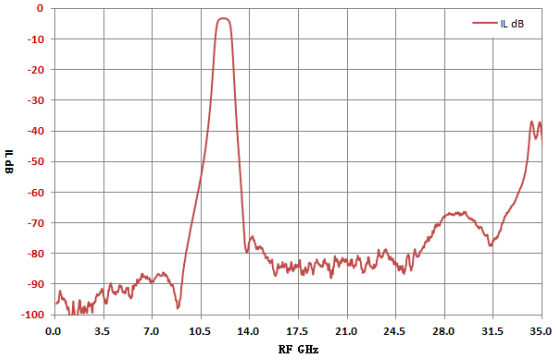
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



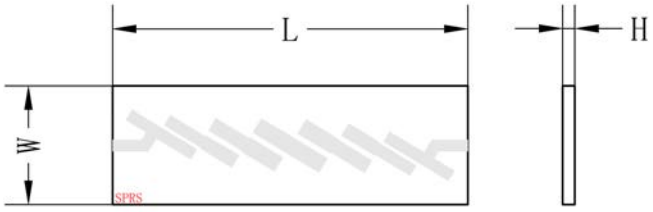
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	12.0	GHz
工作带宽	0	GHz
中心损耗	6.5	dB
带内波动	0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0	ns
带外抑制	35@DC-11.4GHz	dBc
带外抑制	35@12.6-20.0GHz	dBc

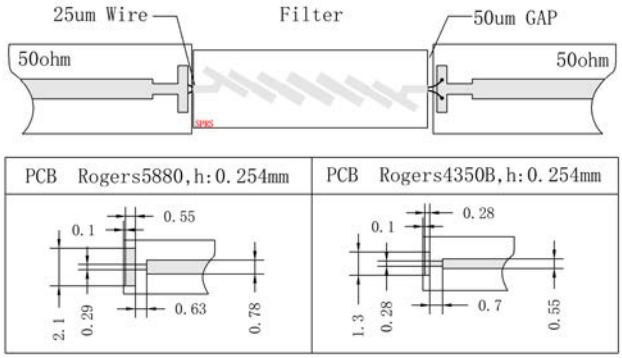
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



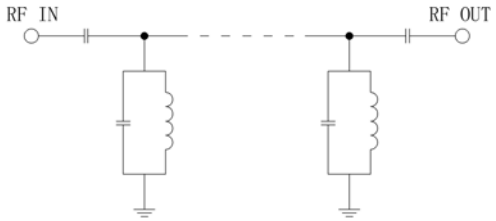
推荐装配图



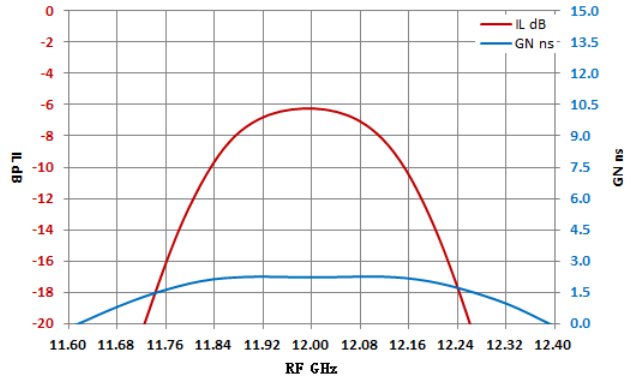
注意事项

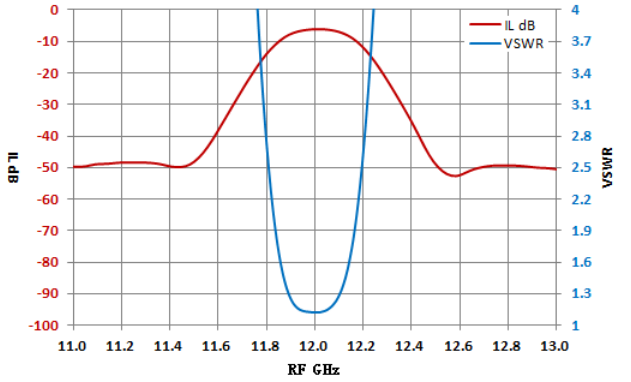
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

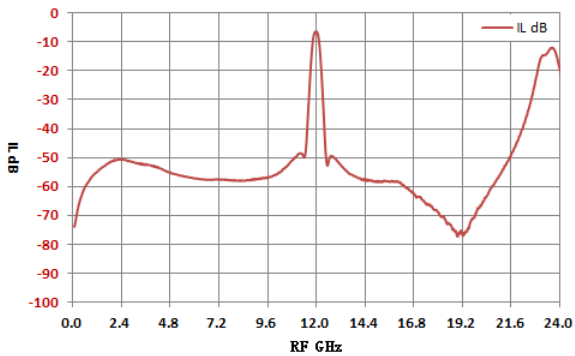
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



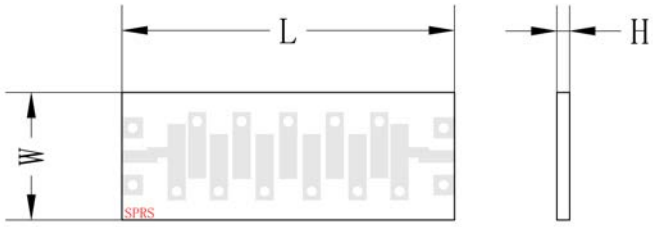
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	12.3	GHz
工作带宽	12.0-12.6	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	35@DC-10.6GHz	dBc
带外抑制	40@14.5-30.0GHz	dBc

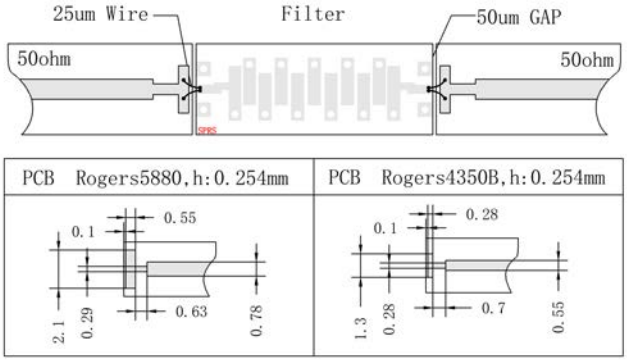
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：4.8，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



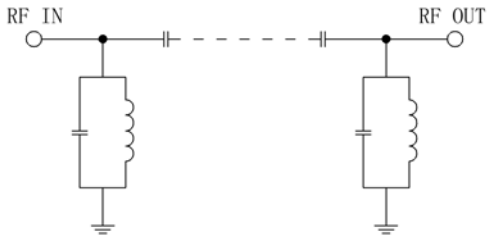
推荐装配图



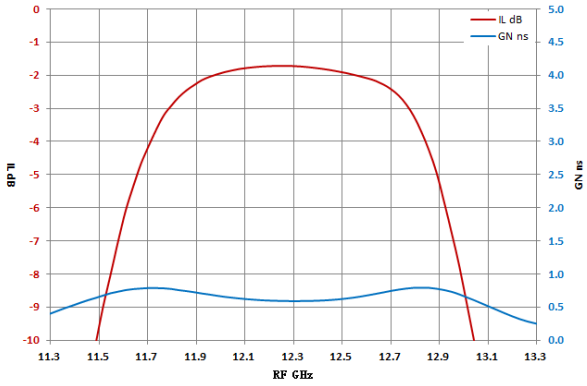
注意事项

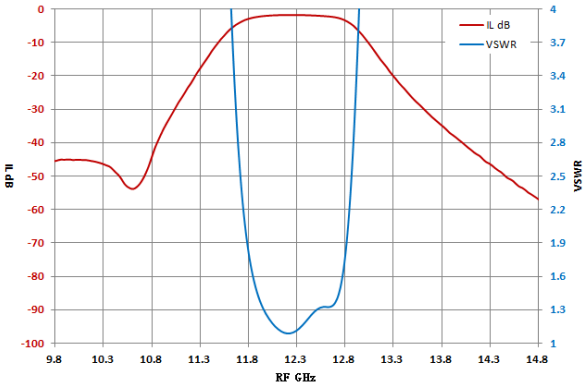
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

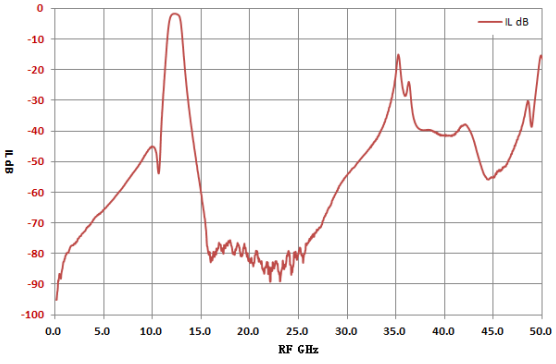
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



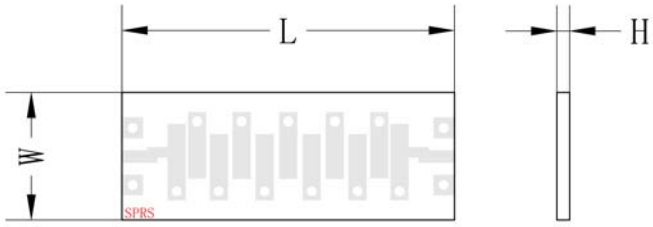
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	12.75	GHz
工作带宽	12.0-13.5	GHz
中心损耗	2.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-10.9GHz	dBc
带外抑制	40@14.7-31.0GHz	dBc

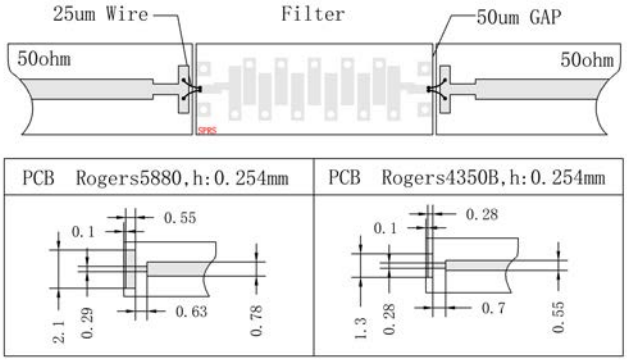
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



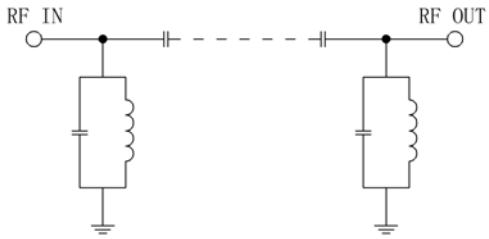
推荐装配图



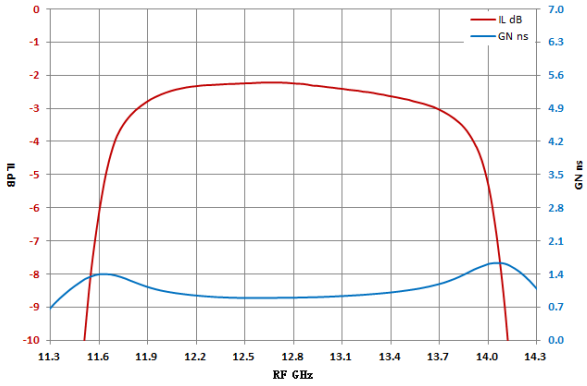
注意事项

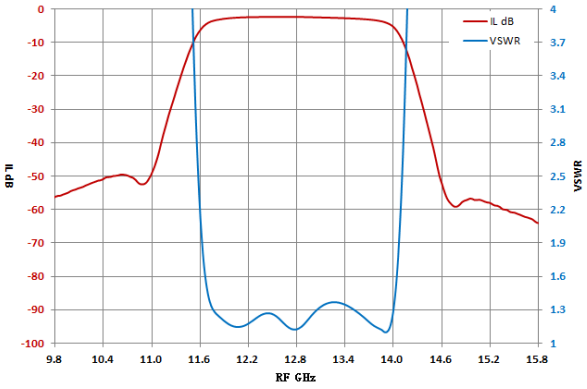
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

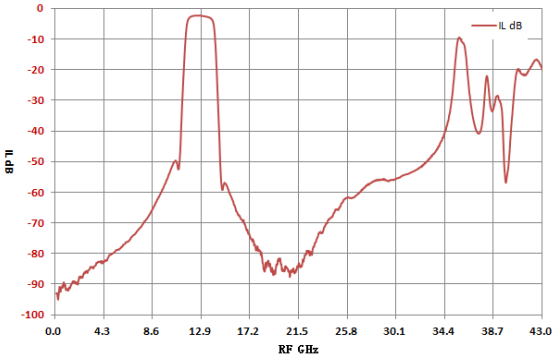
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



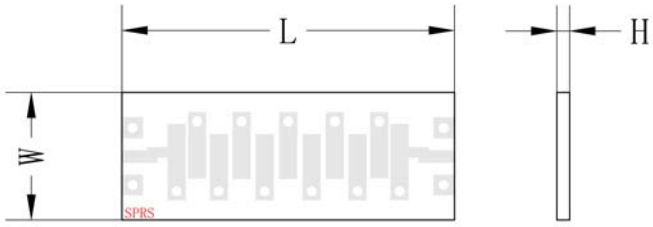
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	13.5	GHz
工作带宽	12.0-15.0	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-10.6GHz	dBc
带外抑制	40@16.8-32.0GHz	dBc

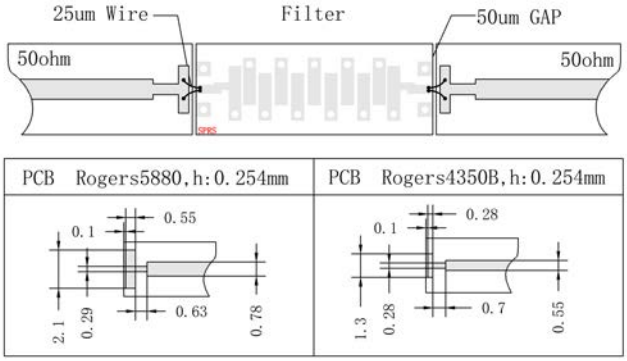
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



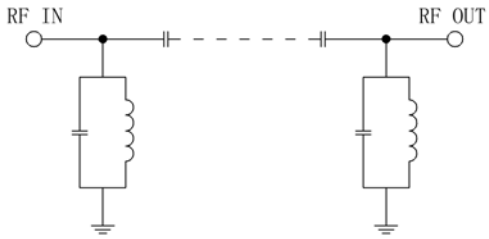
推荐装配图



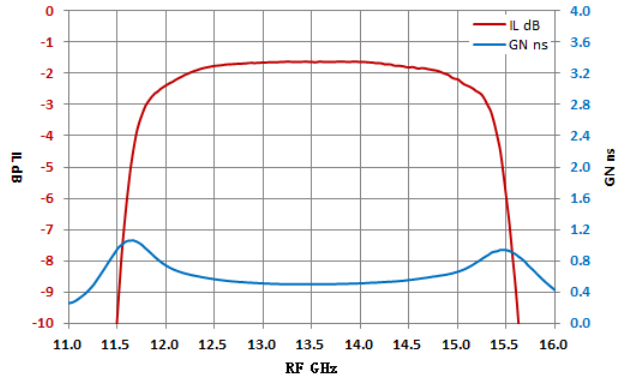
注意事项

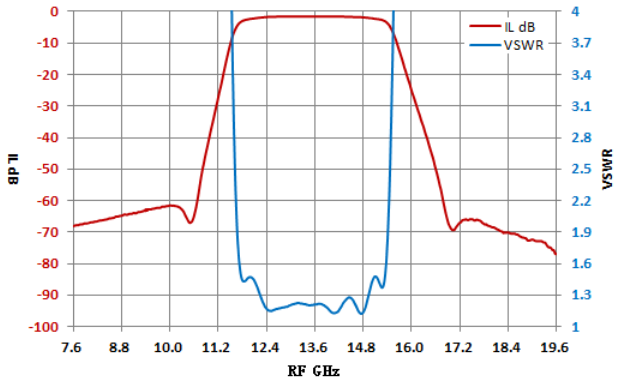
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

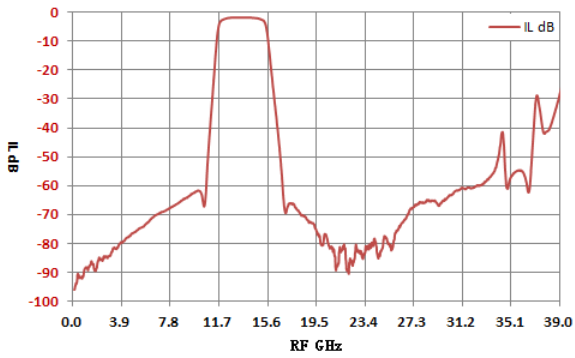
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

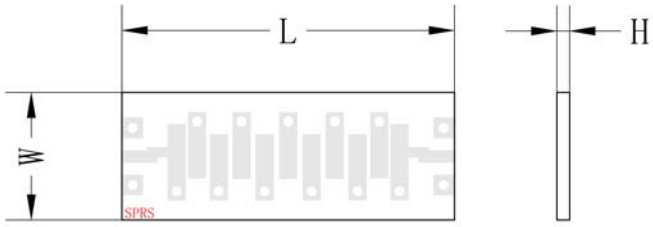
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	14.1	GHz
工作带宽	12.0-16.2	GHz
中心损耗	1.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-9.0GHz	dBc
带外抑制	40@18.0-30.0GHz	dBc

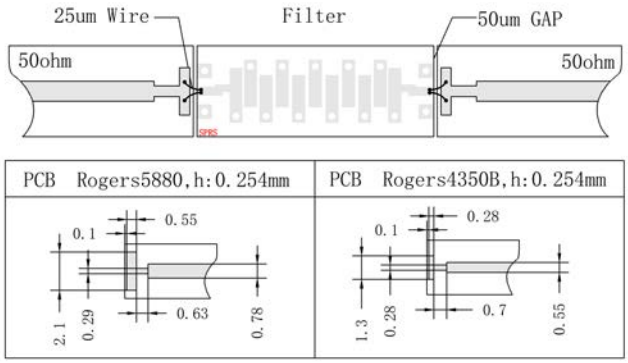
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



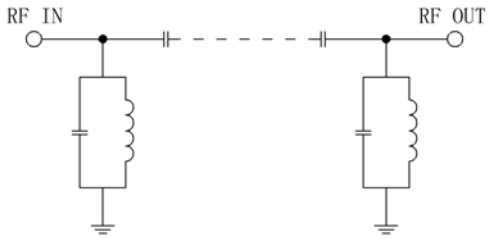
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

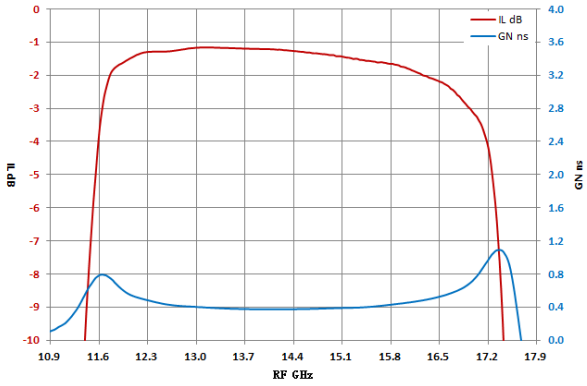
参考实物图

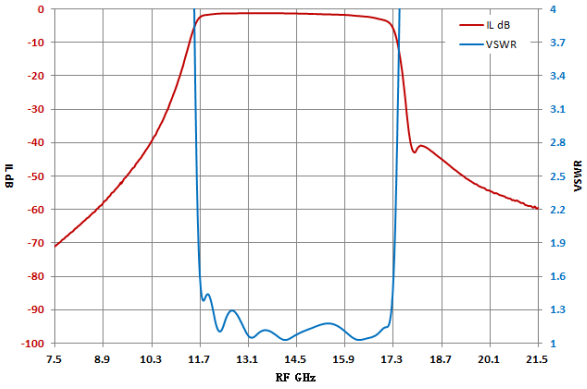


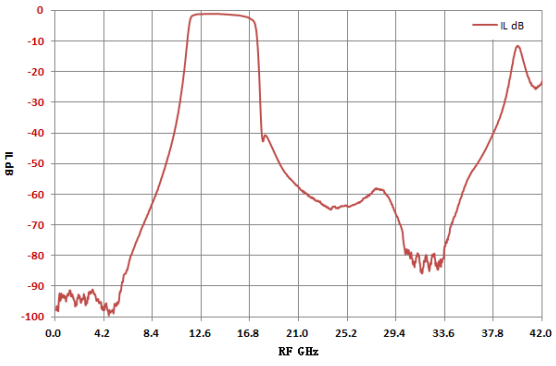
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



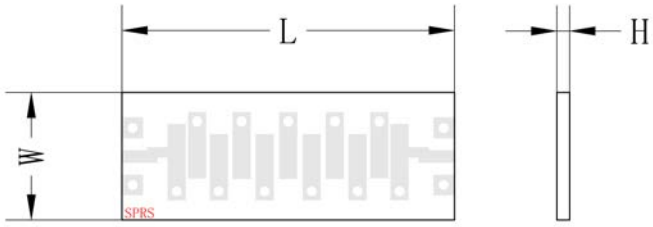
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	14.8	GHz
工作带宽	12.0-17.6	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-9.6GHz	dBc
带外抑制	40@19.8-37.0GHz	dBc

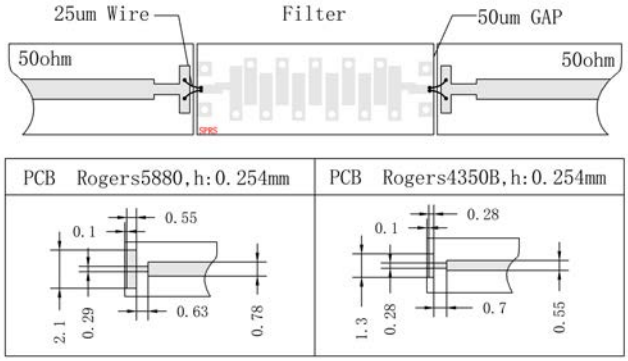
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



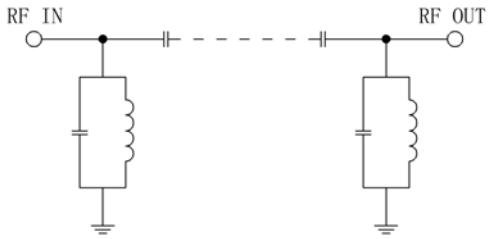
推荐装配图



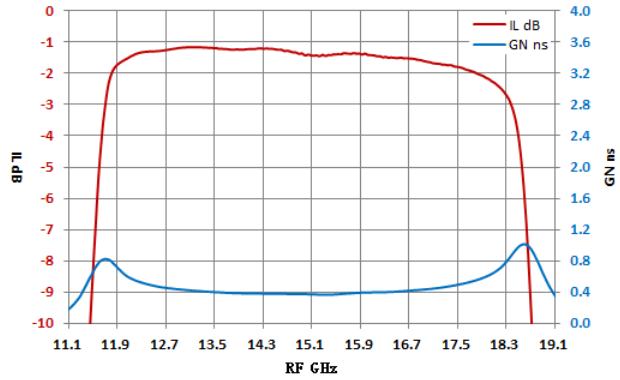
注意事项

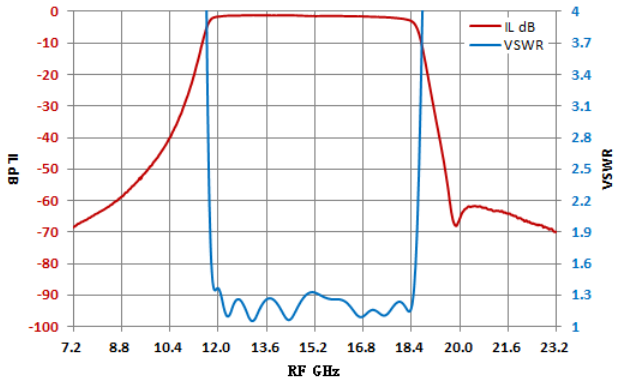
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

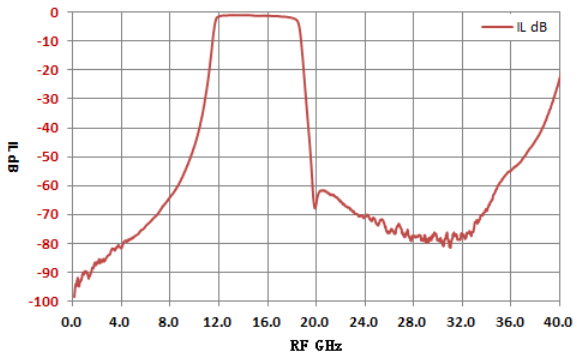
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



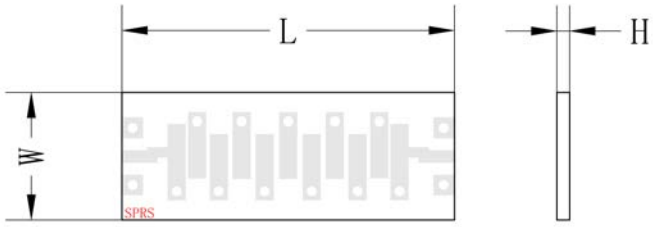
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	15.2	GHz
工作带宽	12.0-18.4	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	30@DC-10.4GHz	dBc
带外抑制	35@20.8-38.0GHz	dBc

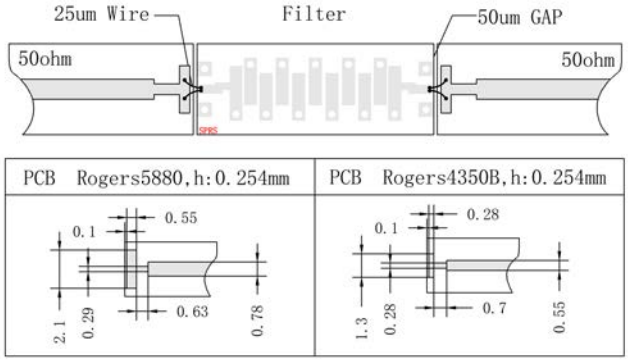
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



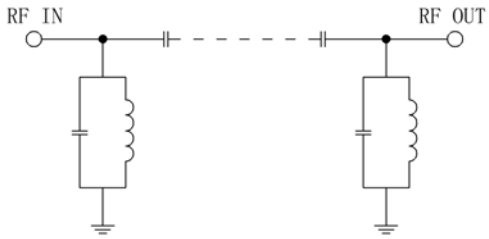
推荐装配图



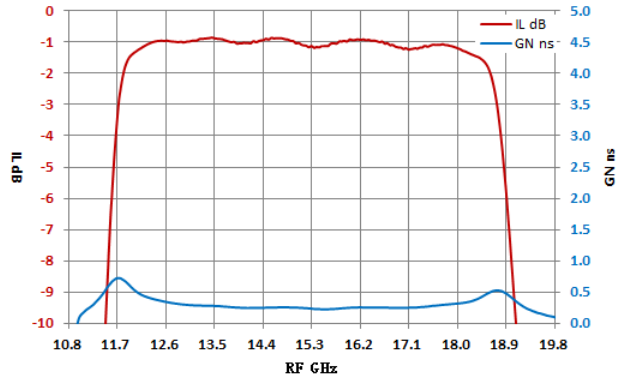
注意事项

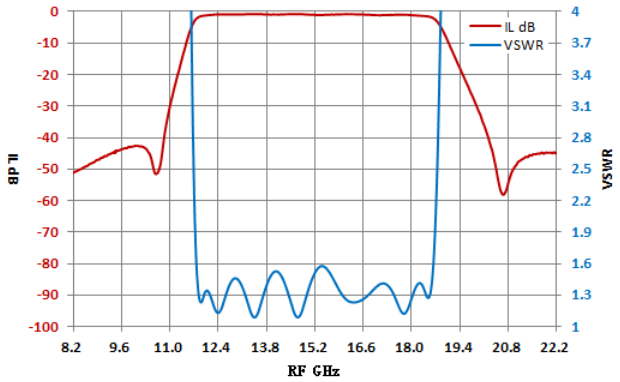
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

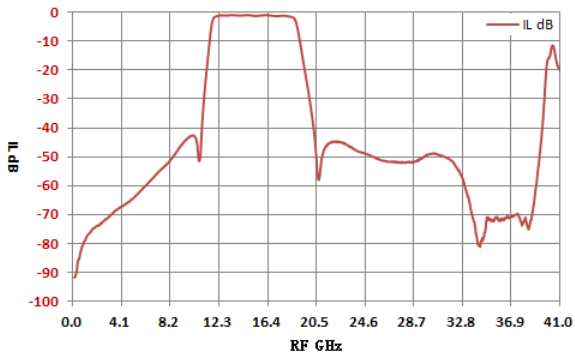
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

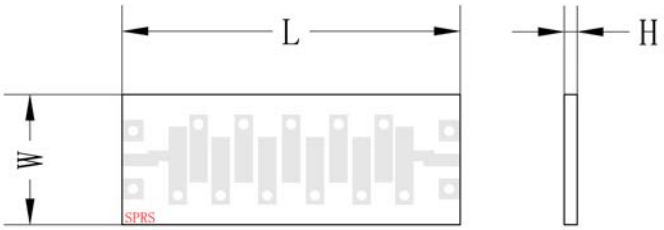
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	15.3	GHz
工作带宽	12.0-18.6	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	50@DC-10.0GHz	dBc
带外抑制	50@23.2-37.0GHz	dBc

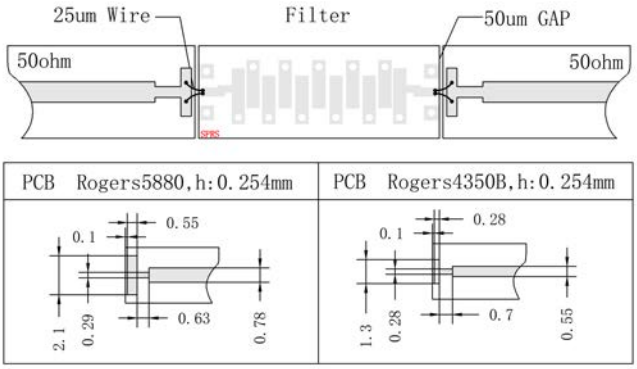
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：6.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

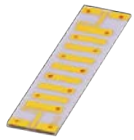
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

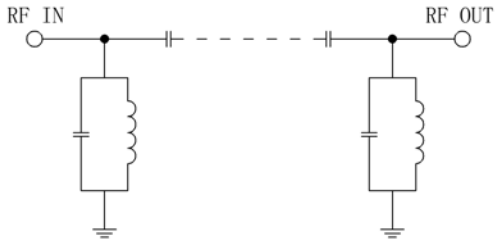
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

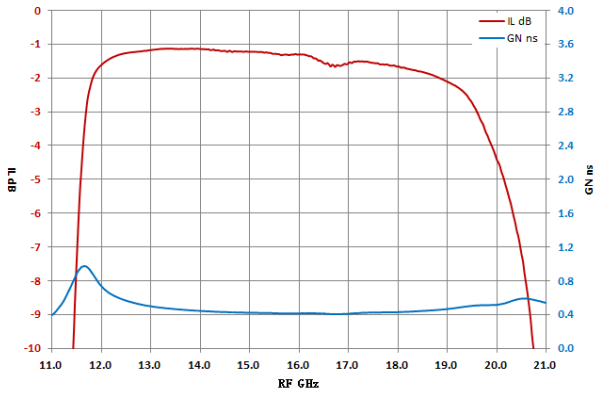
参考图

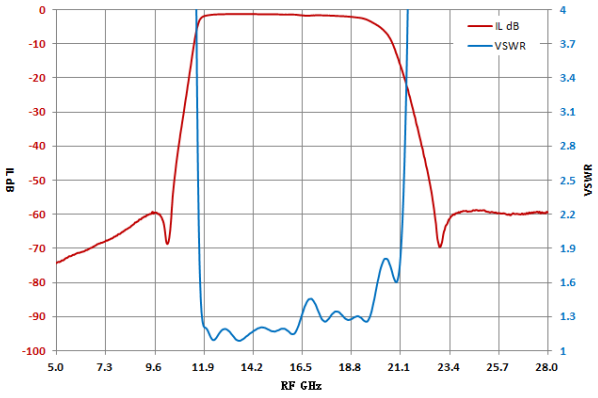


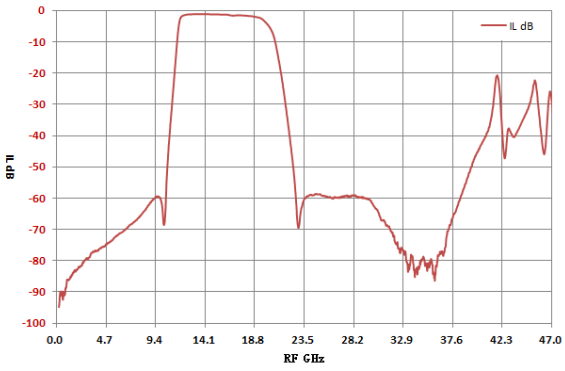
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

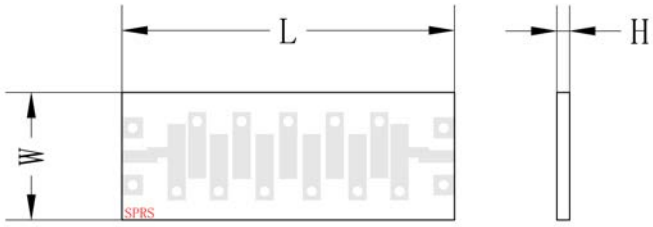
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	12.1	GHz
工作带宽	12.05-12.15	GHz
中心损耗	3.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	1.0	ns
带外抑制	40@DC-11.0GHz	dBc
带外抑制	40@13.0-30.0GHz	dBc

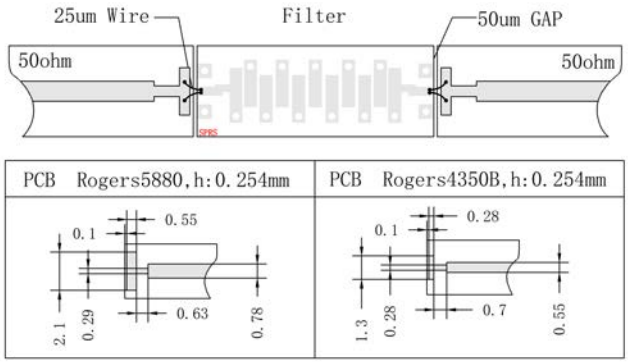
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.5，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



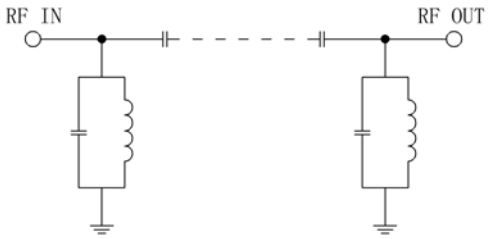
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

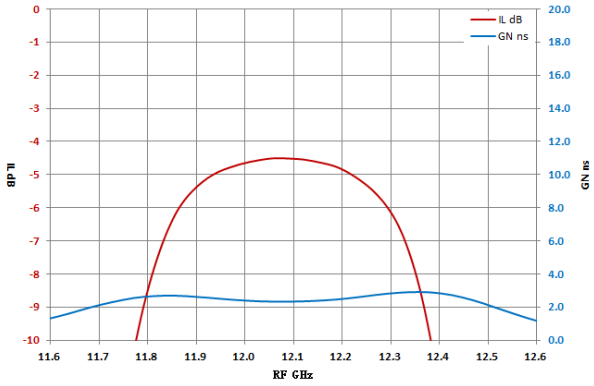
参考实物图

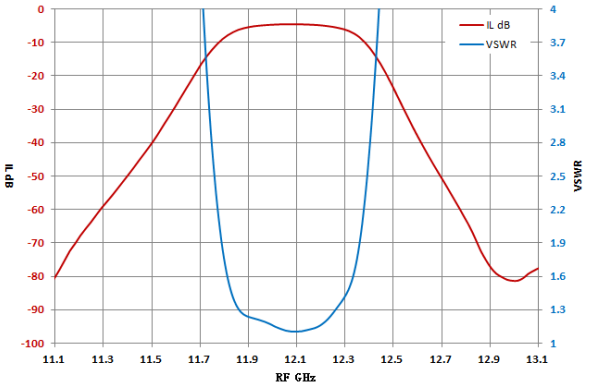


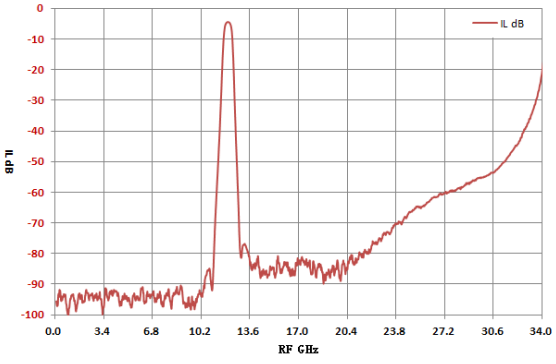
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

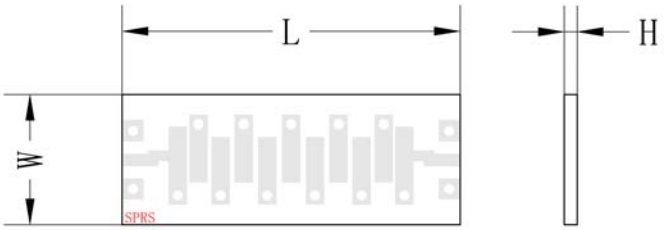
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	12.45	GHz
工作带宽	12.2-12.7	GHz
中心损耗	3.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-11.3GHz	dBc
带外抑制	40@13.8-25.0GHz	dBc

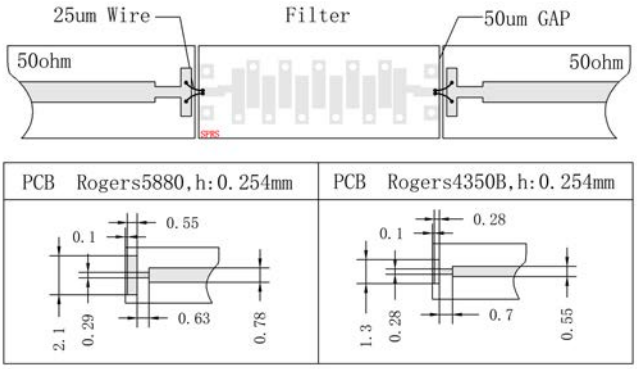
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：7.0，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

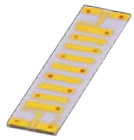
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

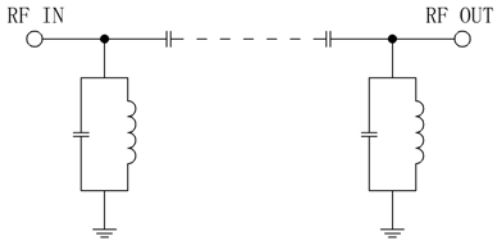
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

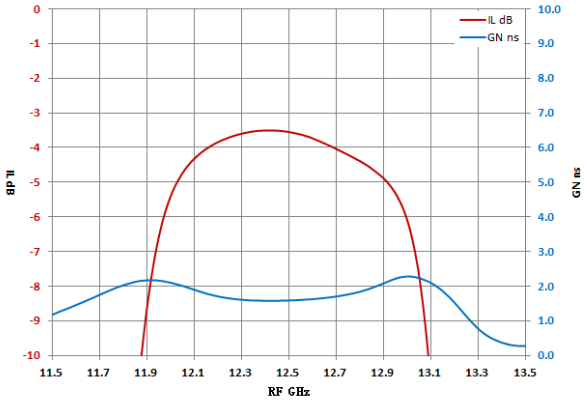
参考图

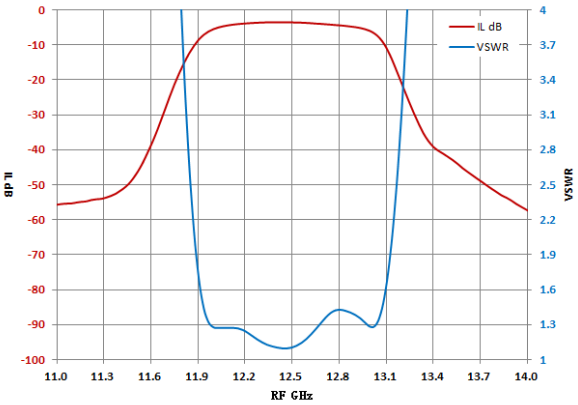


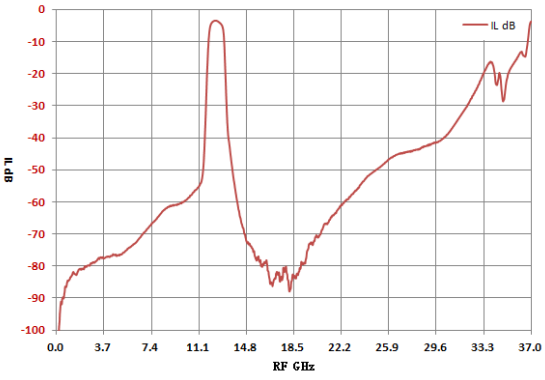
原理图



典型曲线







陶瓷滤波器 STBP127-1R1-M488

工作带宽 12.2-13.3GHz,带外抑制 40@DC-11.2GHz,40@14.4-33.0GHz

产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



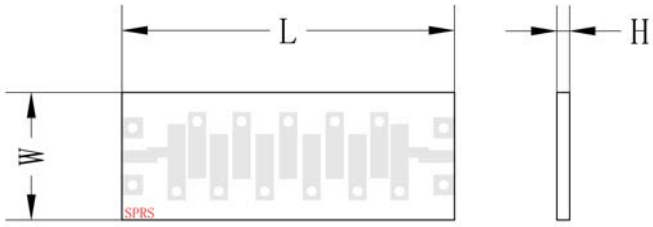
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	12.7	GHz
工作带宽	12.2-13.3	GHz
中心损耗	3.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-11.2GHz	dBc
带外抑制	40@14.4-33.0GHz	dBc

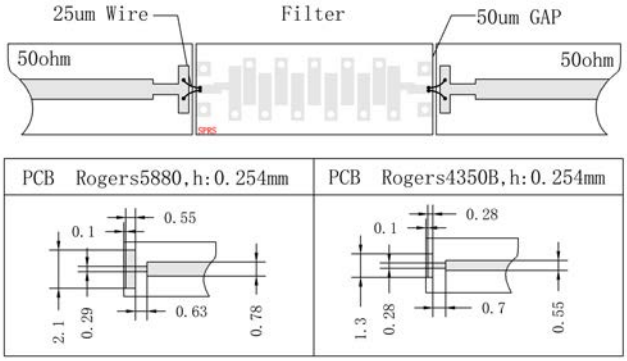
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



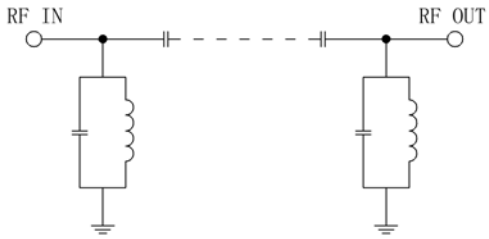
推荐装配图



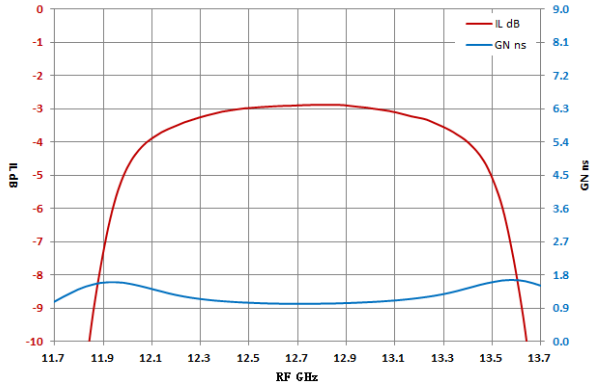
注意事项

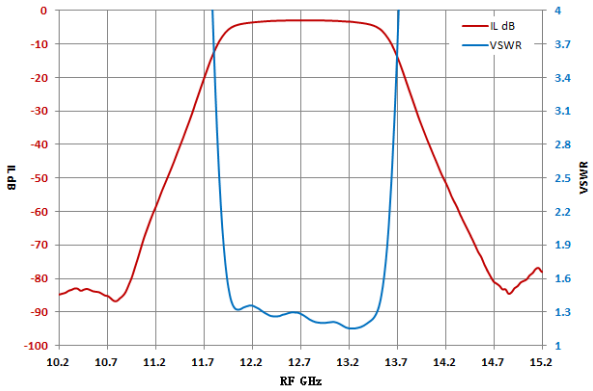
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

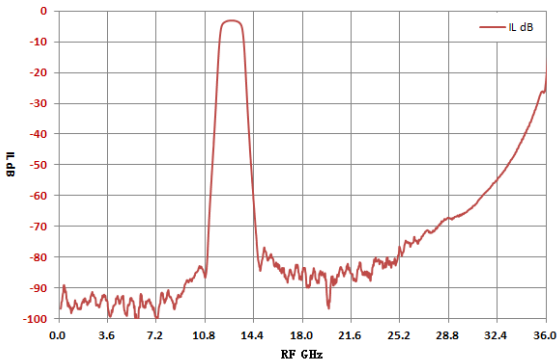
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



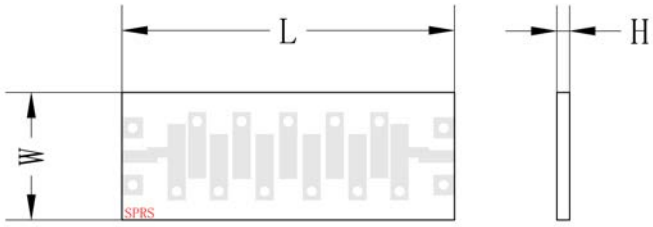
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	12.8	GHz
工作带宽	12.2-13.4	GHz
中心损耗	3.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-11.3GHz	dBc
带外抑制	40@14.7-32.0GHz	dBc

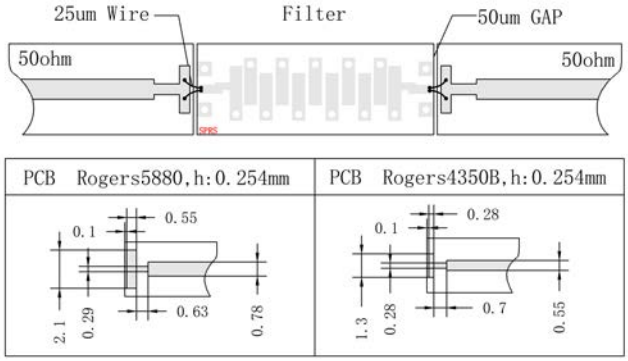
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



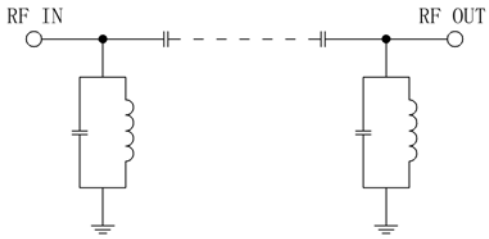
推荐装配图



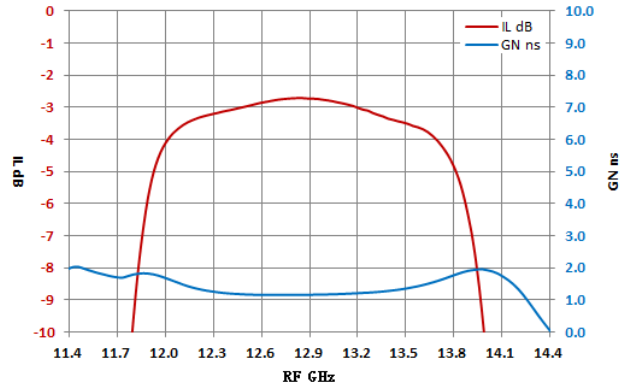
注意事项

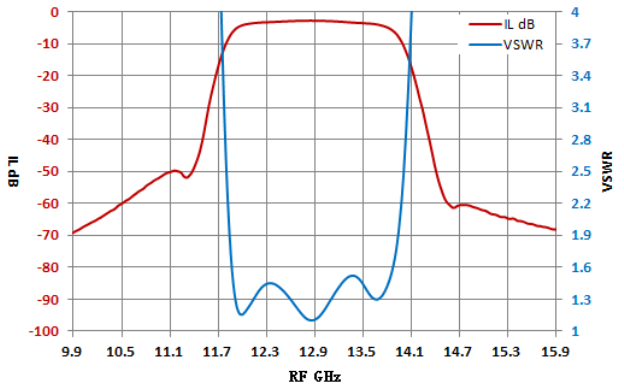
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

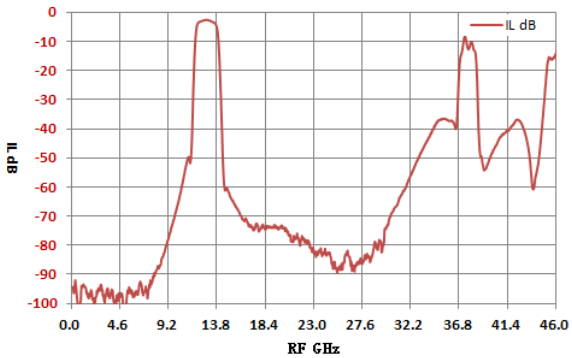
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



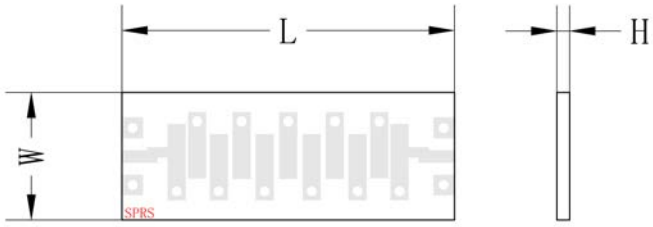
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	17.0	GHz
工作带宽	12.2-21.8	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-6.7GHz	dBc
带外抑制	35@24.5-39.0GHz	dBc

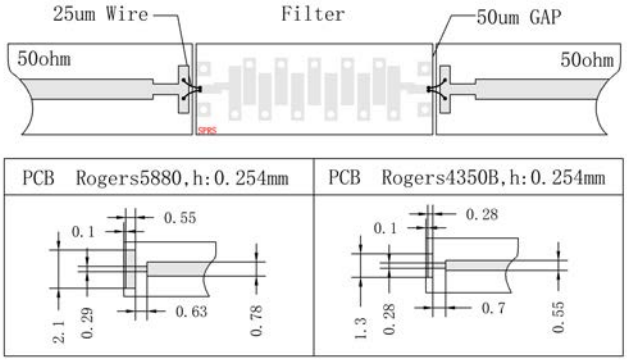
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



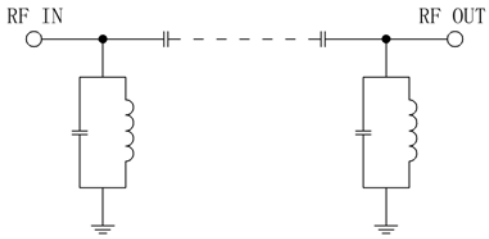
推荐装配图



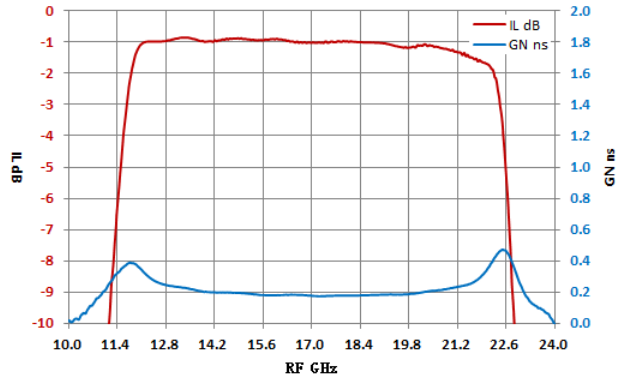
注意事项

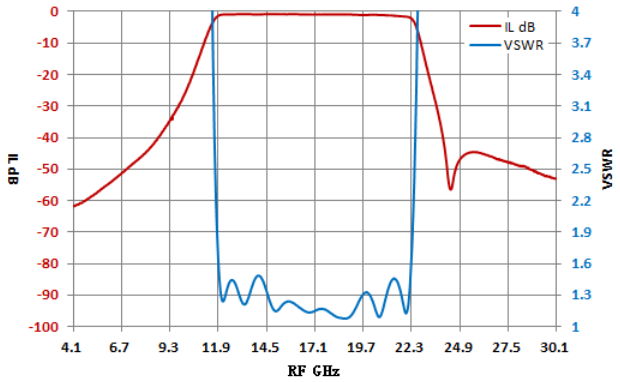
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

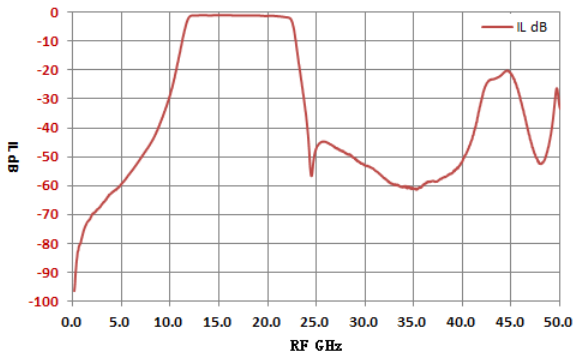
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



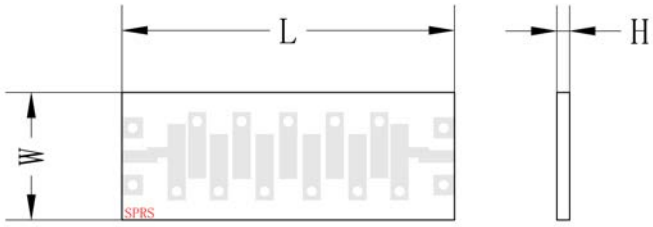
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	13.6	GHz
工作带宽	12.3-14.8	GHz
中心损耗	2.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-11.0GHz	dBc
带外抑制	40@16.4-31.0GHz	dBc

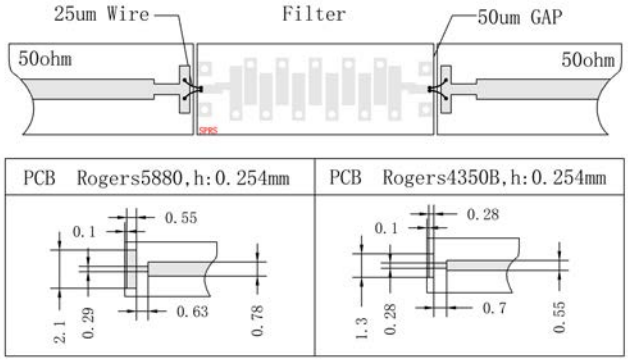
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.0，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



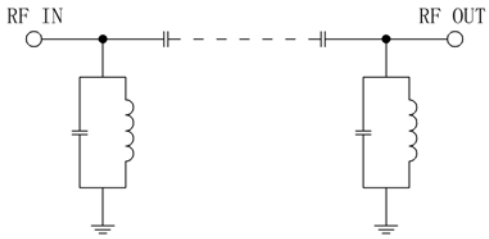
推荐装配图



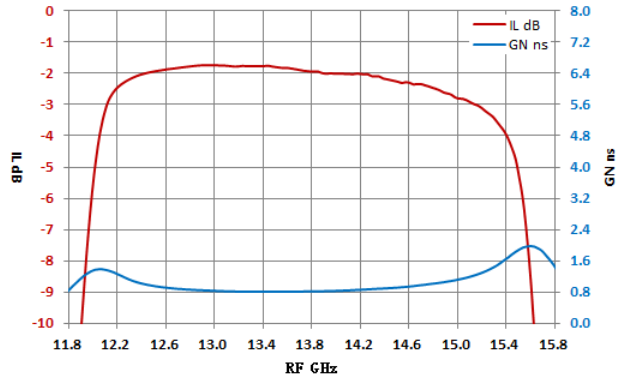
注意事项

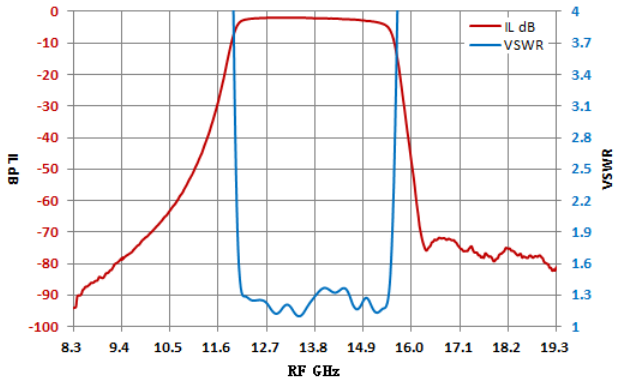
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

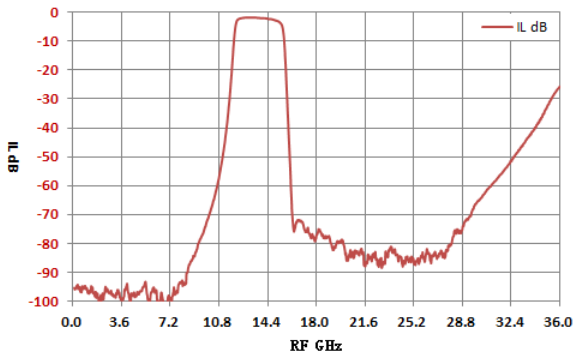
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



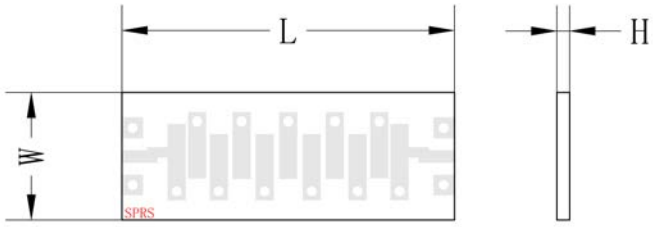
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	13.1	GHz
工作带宽	12.4-13.8	GHz
中心损耗	2.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-11.5GHz	dBc
带外抑制	40@15.0-32.0GHz	dBc

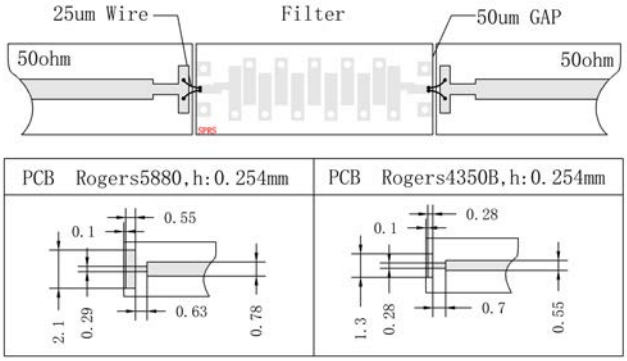
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



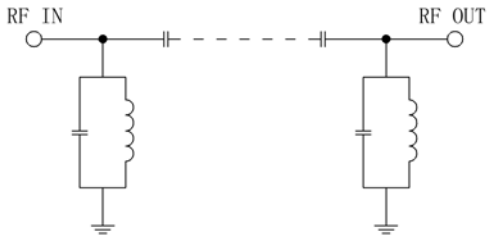
推荐装配图



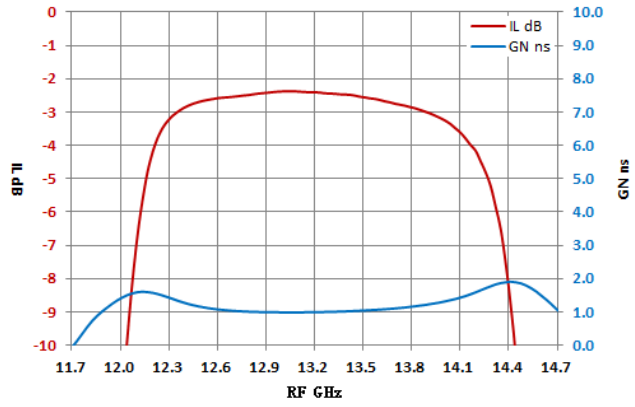
注意事项

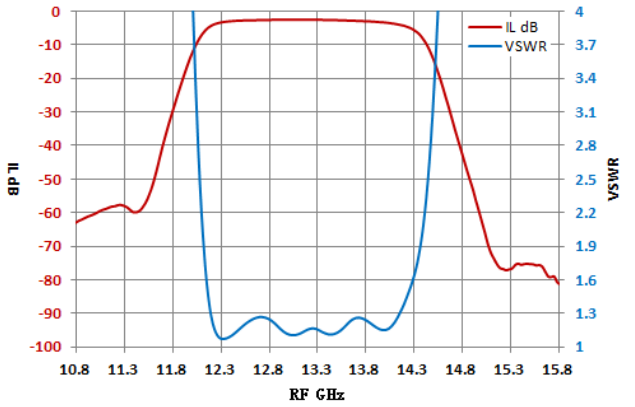
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

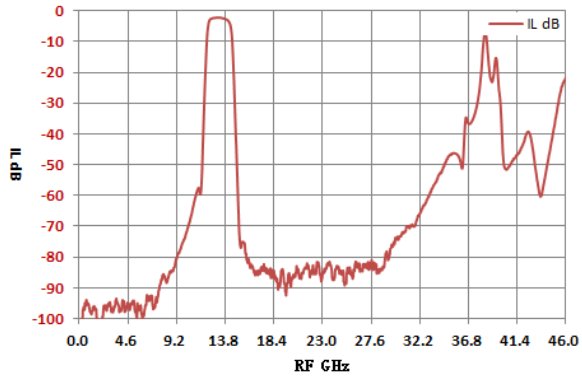
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



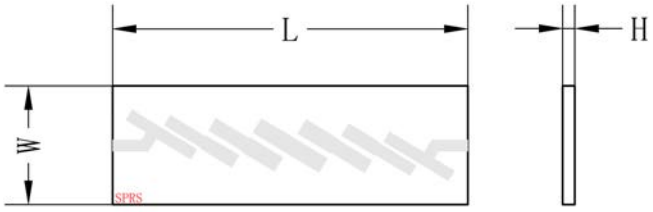
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	12.45	GHz
工作带宽	0	GHz
中心损耗	7.0	dB
带内波动	0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0	ns
带外抑制	35@DC-11.9GHz	dBc
带外抑制	40@13.0-20.0GHz	dBc

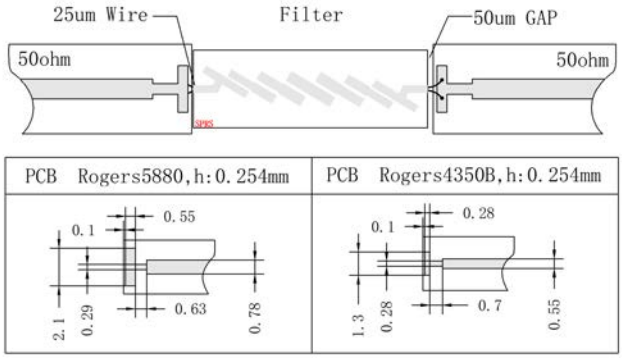
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



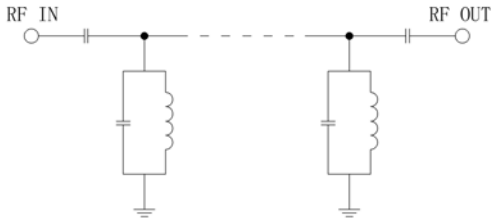
推荐装配图



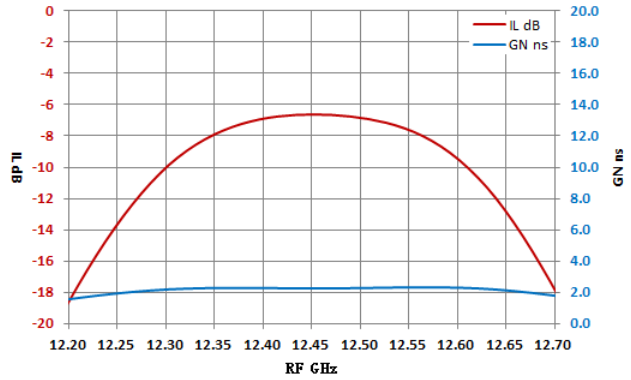
注意事项

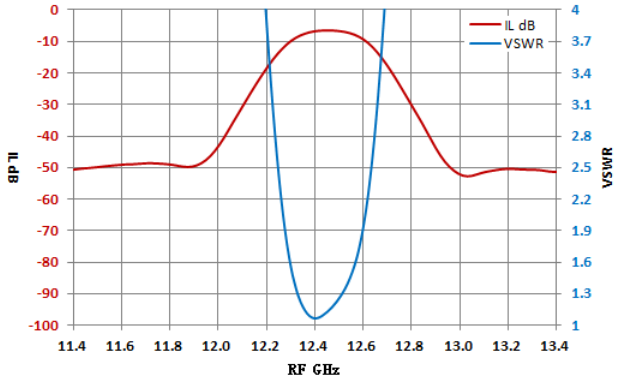
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

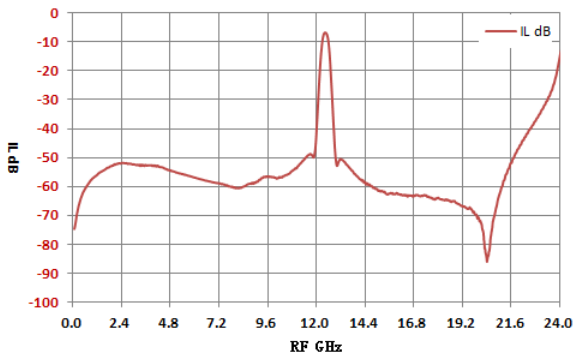
原理图



典型曲线







产品特点

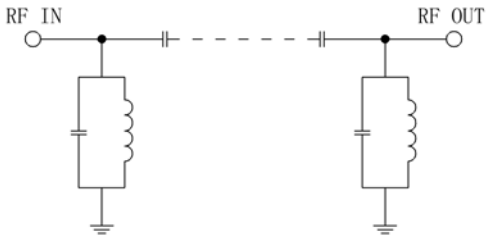
高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



技术要求

项目	参数	单位
中心频率	13.0	GHz
工作带宽	12.5-13.5	GHz
中心损耗	3.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-11.4GHz	dBc
带外抑制	40@14.8-28.0GHz	dBc

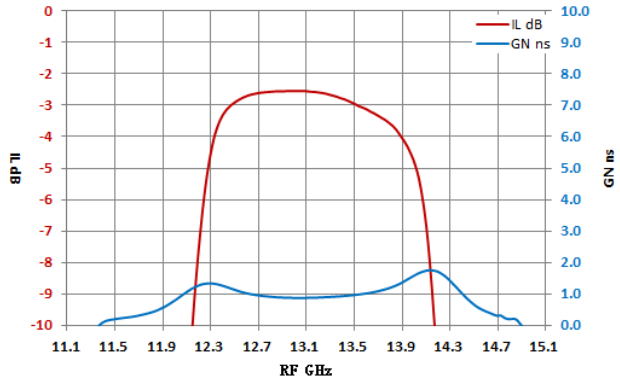
原理图

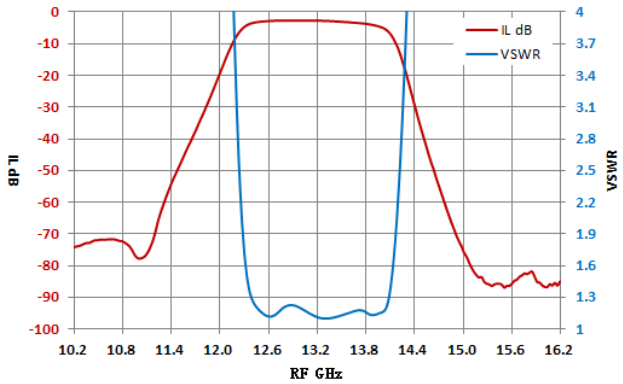


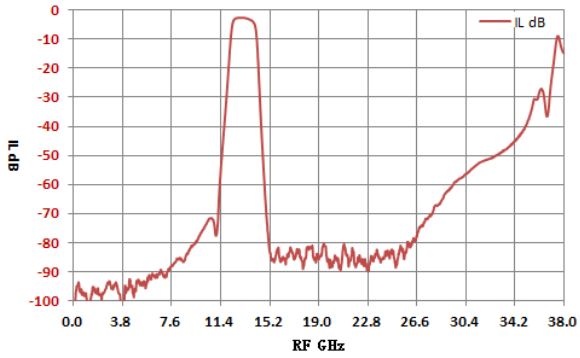
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.5，W：2.5，h：0.26

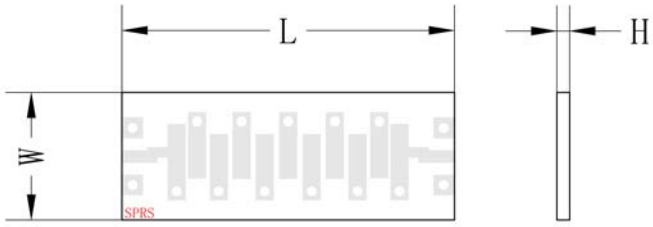
典型曲线



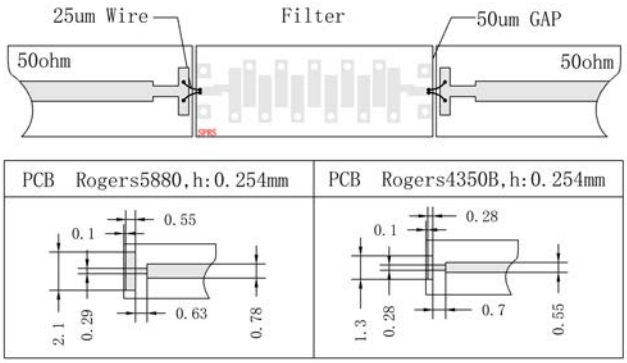




外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



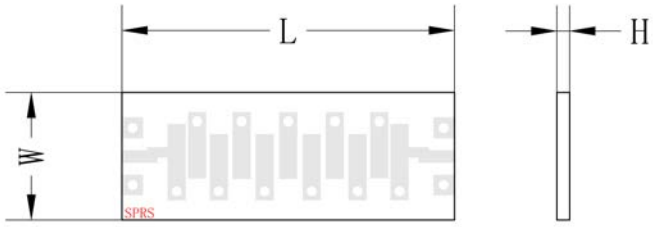
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	13.2	GHz
工作带宽	12.5-13.9	GHz
中心损耗	2.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-11.4GHz	dBc
带外抑制	40@15.2-33.0GHz	dBc

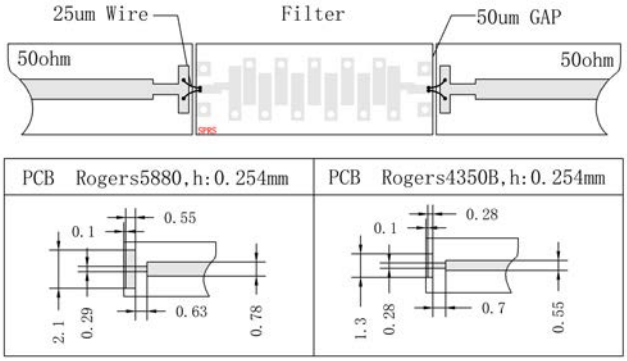
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



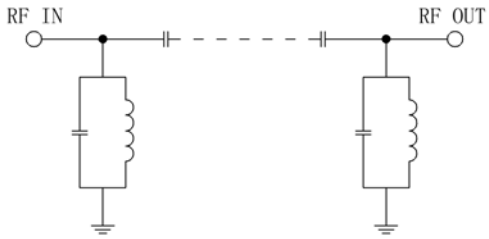
推荐装配图



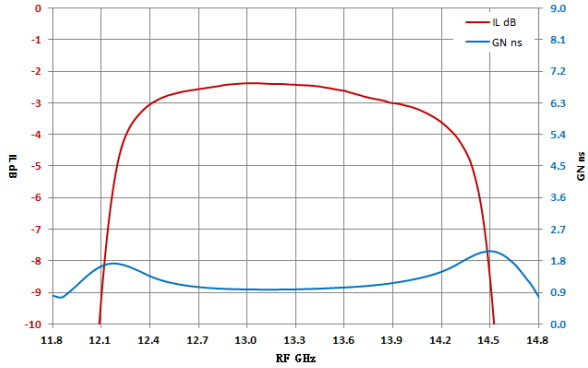
注意事项

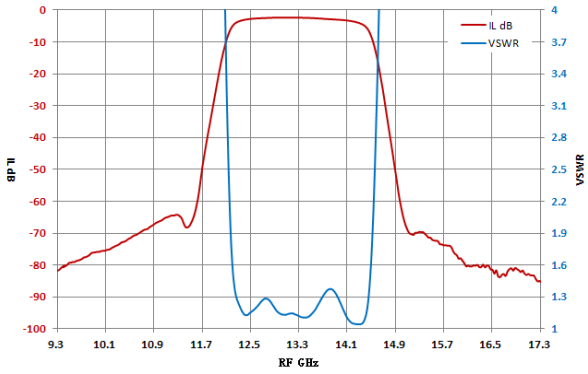
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

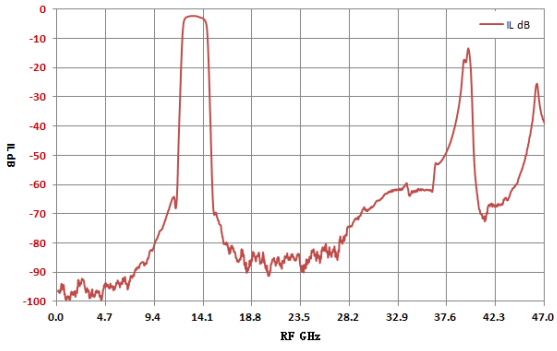
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



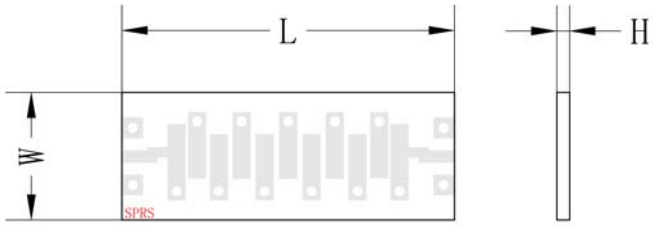
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	13.8	GHz
工作带宽	12.5-15.0	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	28@DC-11.4GHz	dBc
带外抑制	40@16.3-32.0GHz	dBc

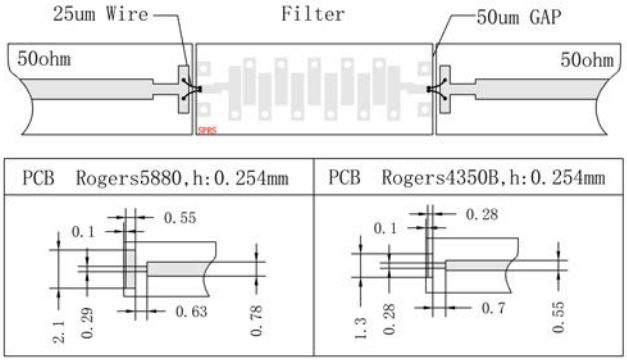
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



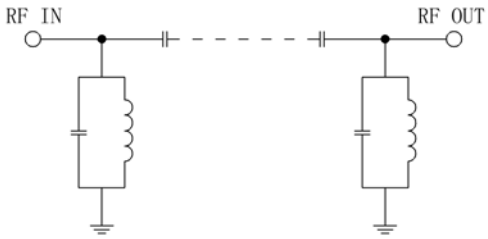
推荐装配图



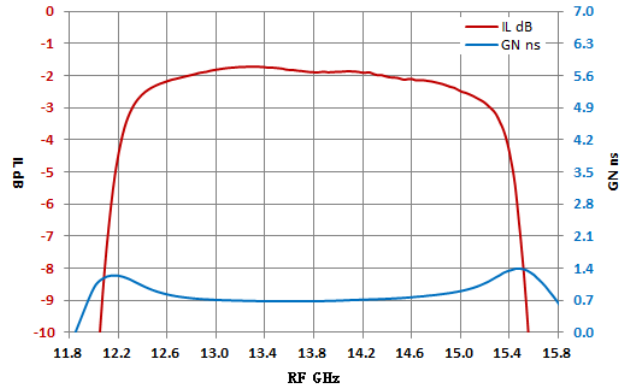
注意事项

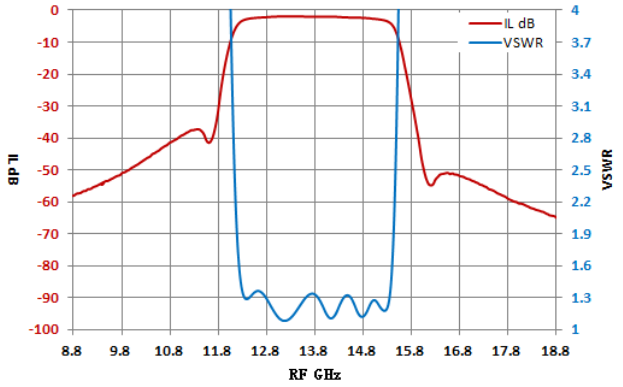
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

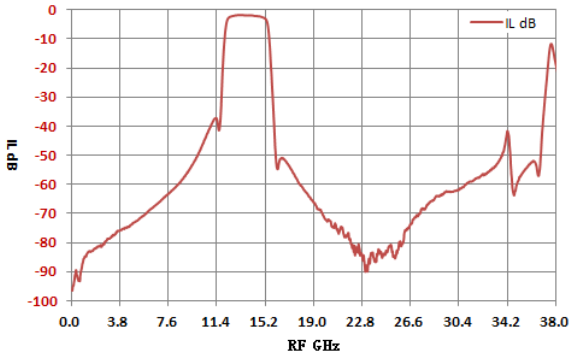
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



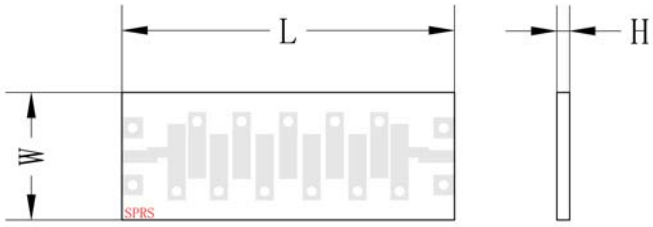
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	14.2	GHz
工作带宽	12.5-15.9	GHz
中心损耗	1.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-11.0GHz	dBc
带外抑制	40@18.0-34.0GHz	dBc

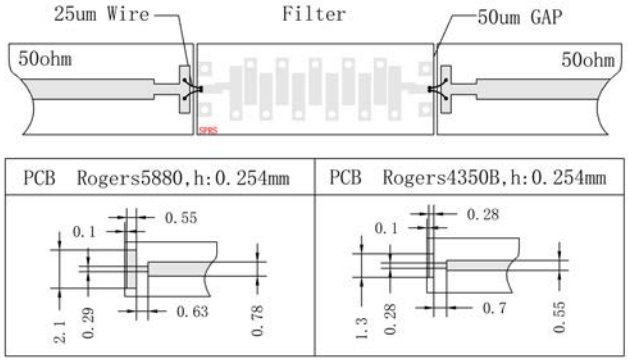
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



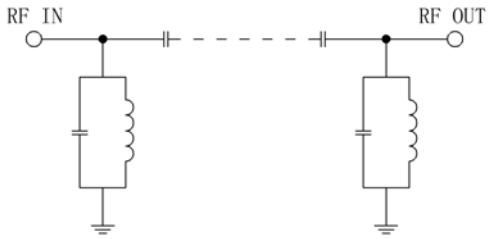
推荐装配图



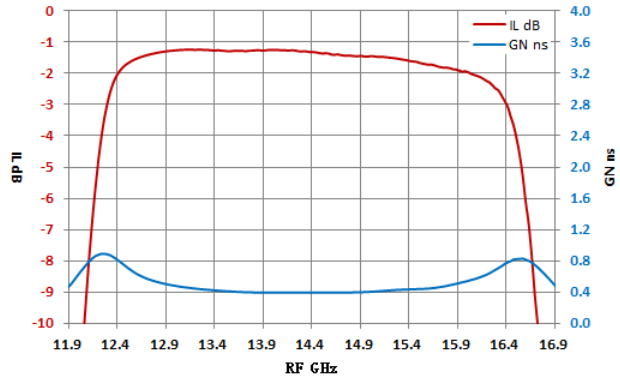
注意事项

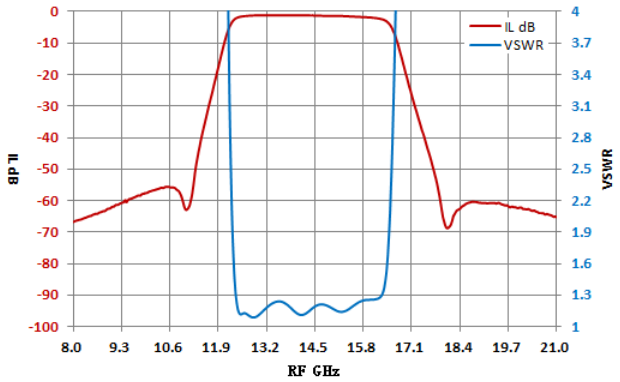
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

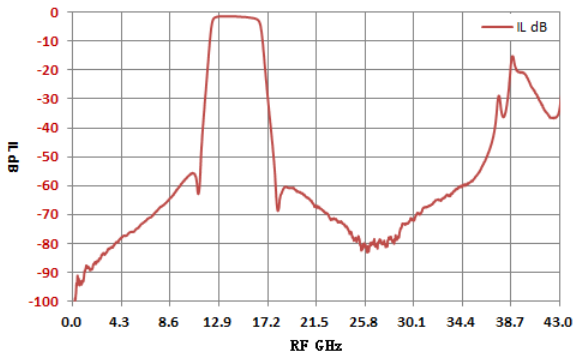
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



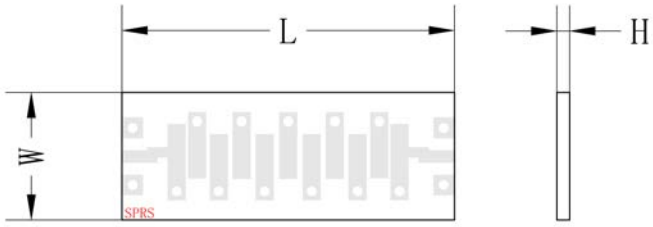
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	15.5	GHz
工作带宽	12.5-18.4	GHz
中心损耗	1.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	35@DC-10.8GHz	dBc
带外抑制	35@20.5-38.0GHz	dBc

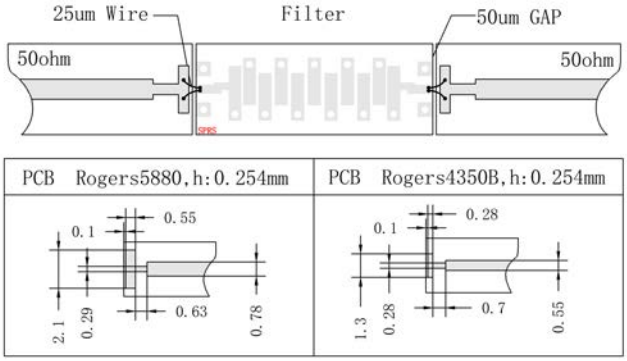
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



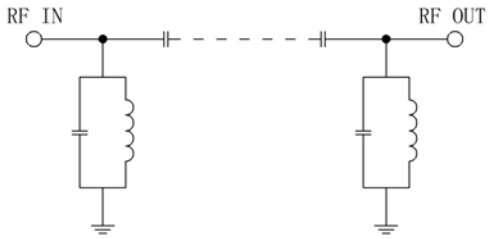
推荐装配图



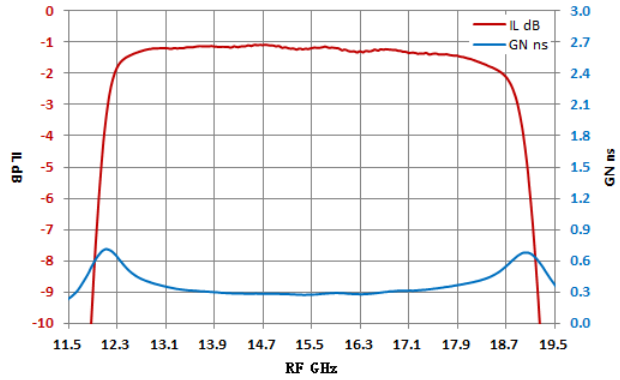
注意事项

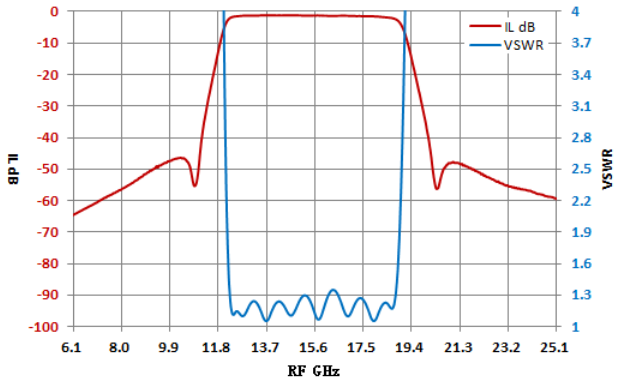
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

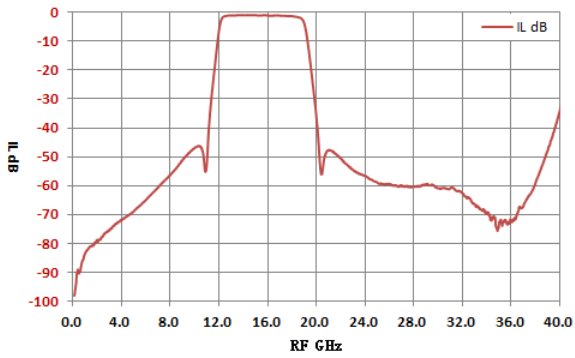
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



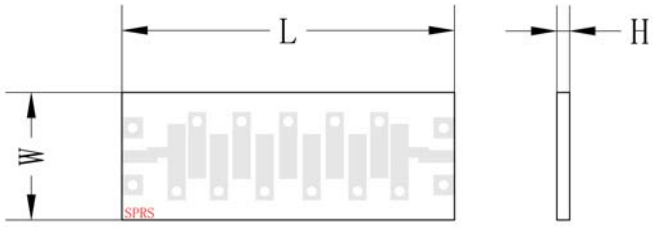
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	14.5	GHz
工作带宽	12.7-16.3	GHz
中心损耗	2.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-11.4GHz	dBc
带外抑制	40@18.2-36.0GHz	dBc

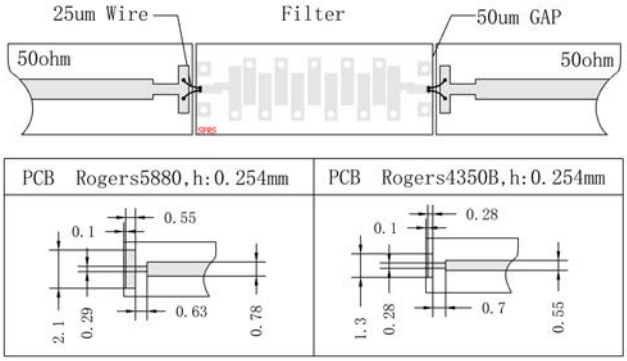
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



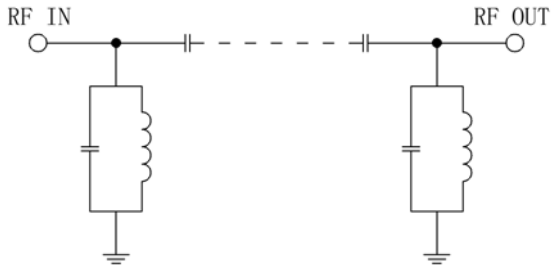
推荐装配图



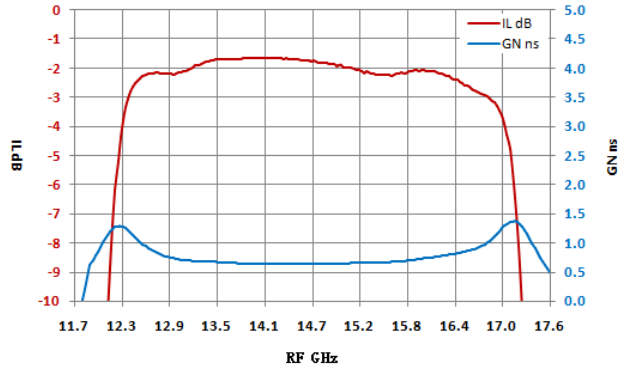
注意事项

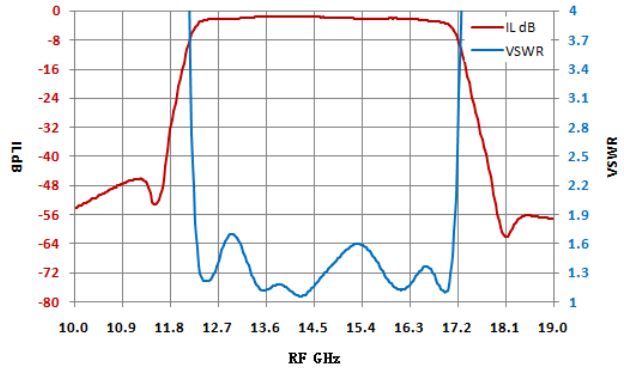
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

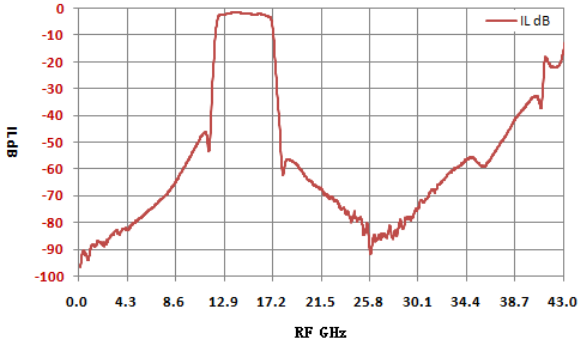
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

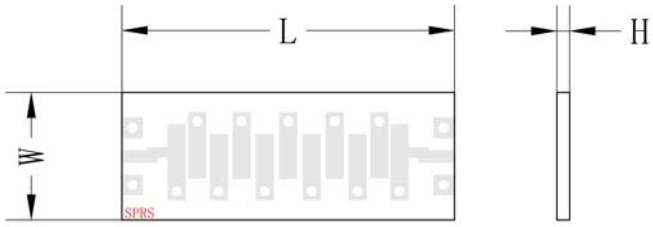
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	13.0	GHz
工作带宽	12.9-13.1	GHz
中心损耗	4.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	1.5	ns
带外抑制	40@DC-12.4GHz	dBc
带外抑制	40@13.6-14.8GHz	dBc

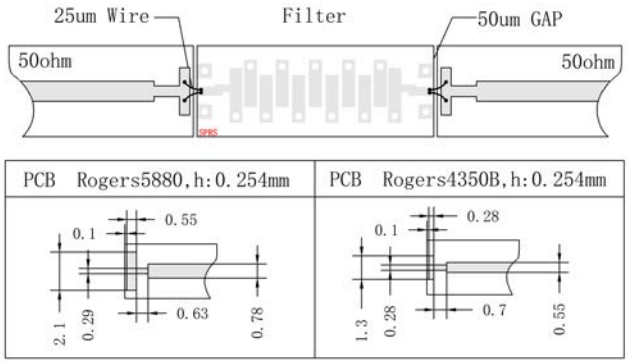
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



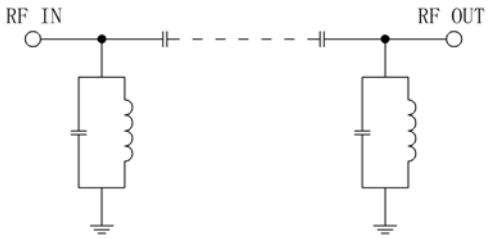
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

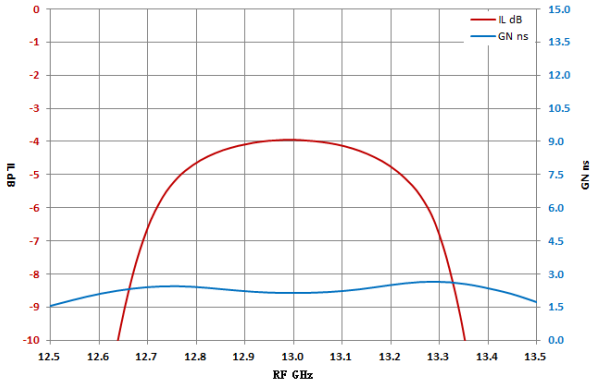
参考实物图

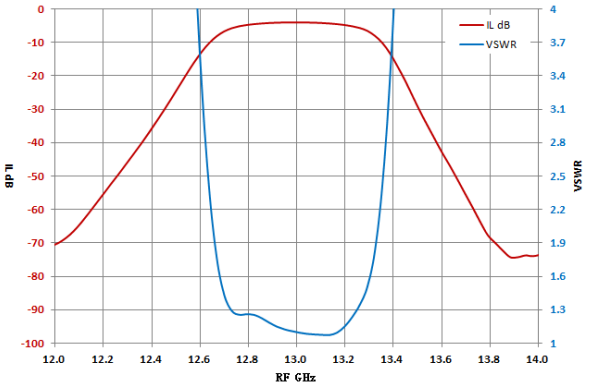


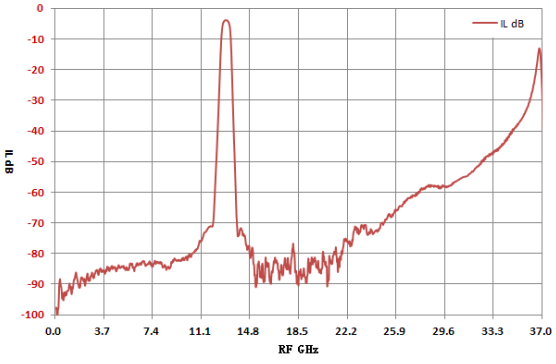
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

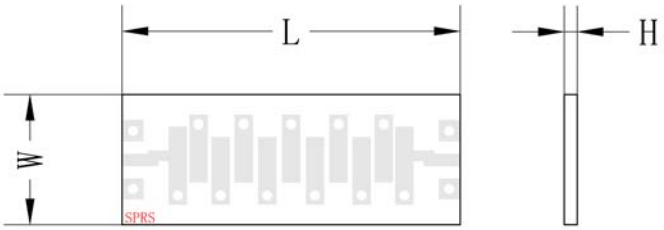
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	13.85	GHz
工作带宽	12.9-14.8	GHz
中心损耗	1.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	50@DC-11.0GHz	dBc
带外抑制	40@16.5-33.0GHz	dBc

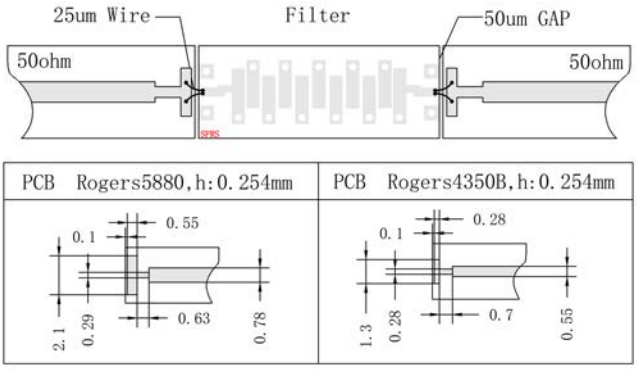
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：7.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

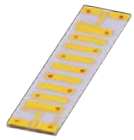
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

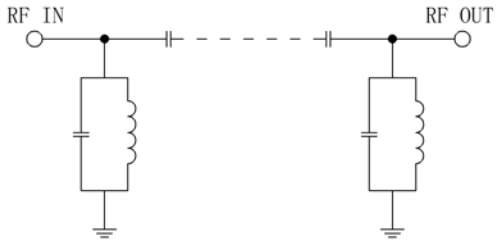
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

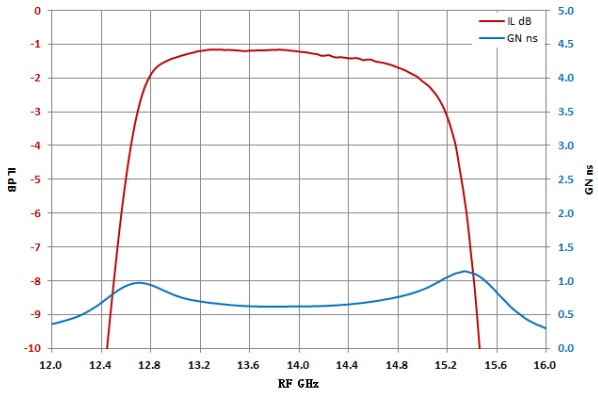
参考图

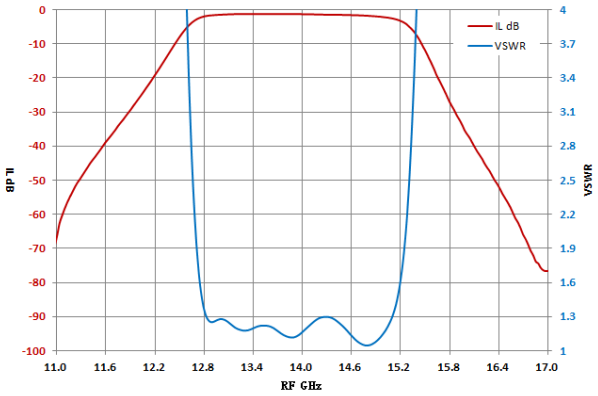


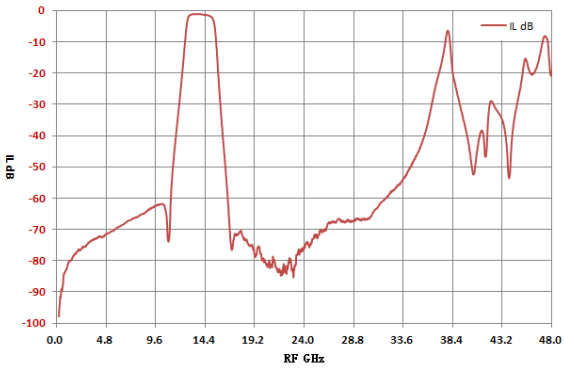
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



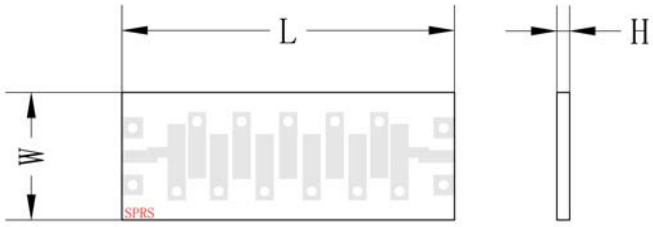
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	14.0	GHz
工作带宽	12.9-15.1	GHz
中心损耗	2.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-11.7GHz	dBc
带外抑制	40@16.5-35.0GHz	dBc

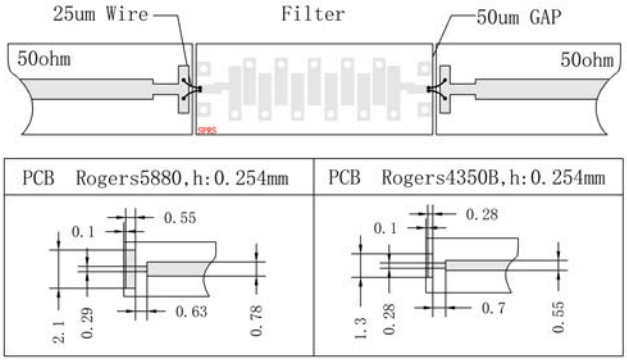
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



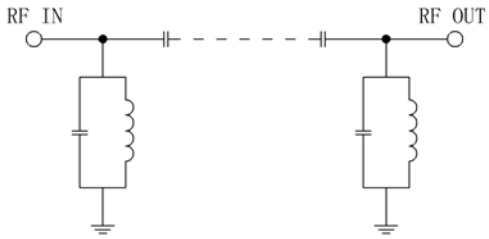
推荐装配图



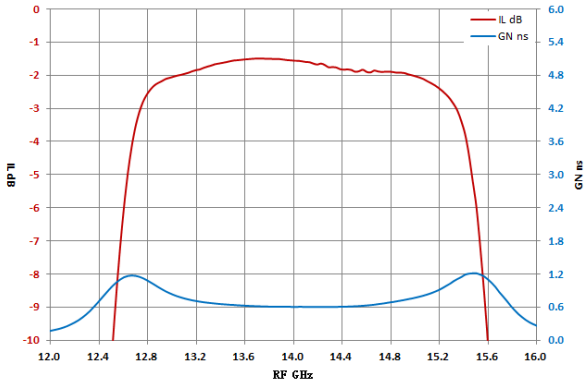
注意事项

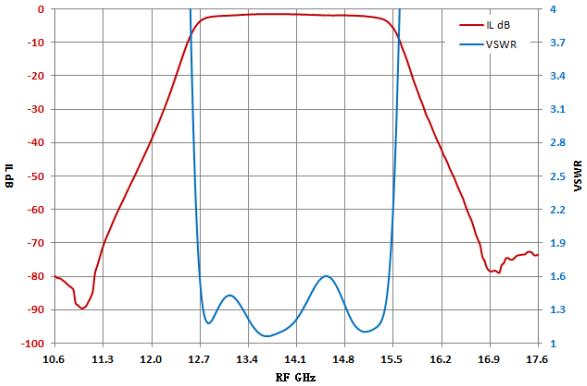
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

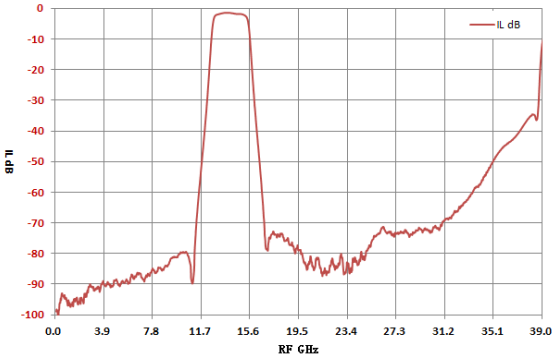
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



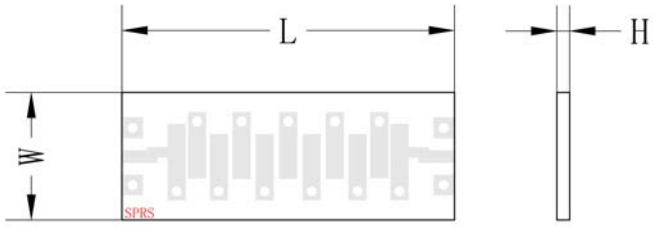
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	14.5	GHz
工作带宽	12.9-16.1	GHz
中心损耗	2.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	35@DC-11.7GHz	dBc
带外抑制	35@17.5-34.0GHz	dBc

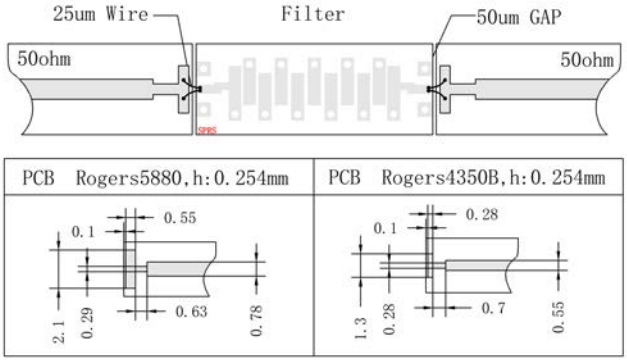
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



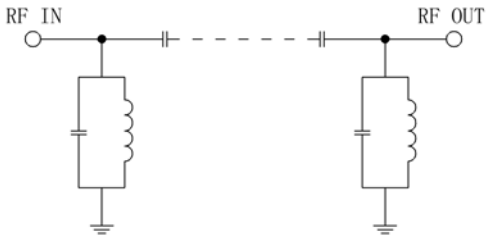
推荐装配图



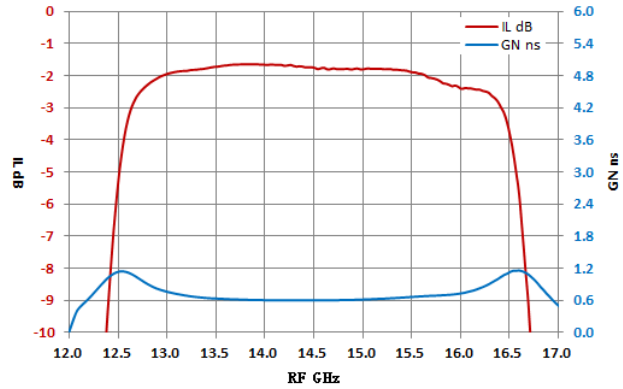
注意事项

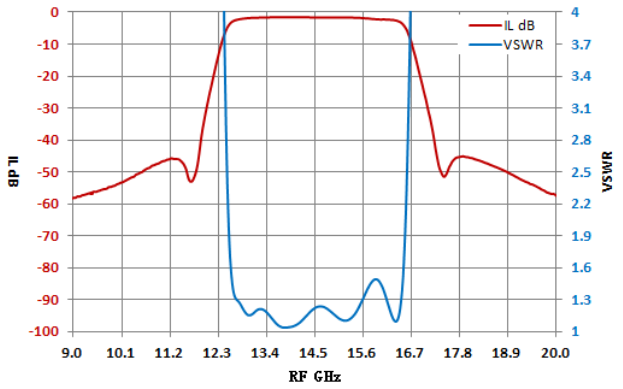
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

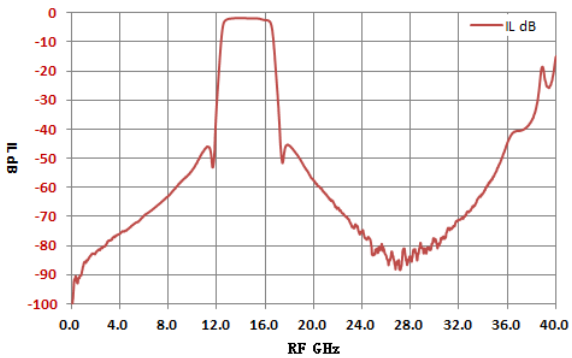
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

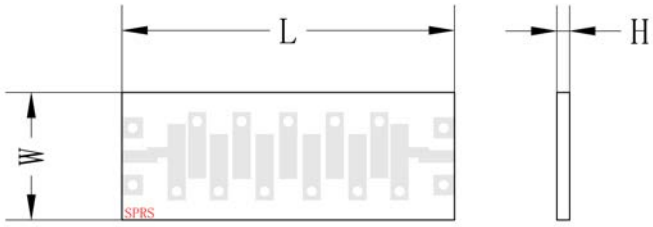
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	13.0	GHz
工作带宽	12.95-13.05	GHz
中心损耗	4.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-12.0GHz	dBc
带外抑制	40@13.8-32.0GHz	dBc

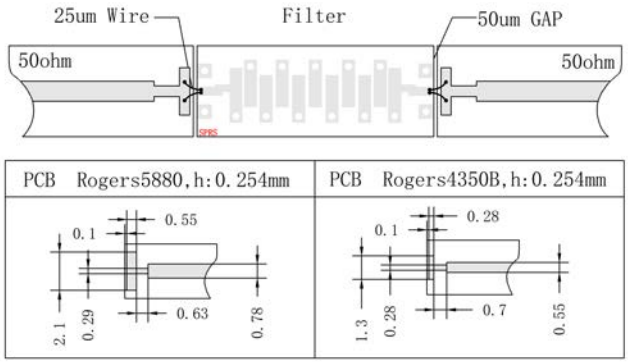
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



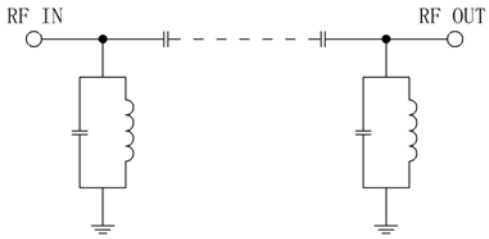
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

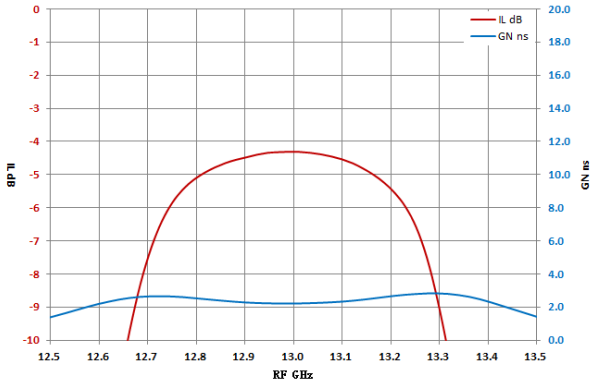
参考实物图

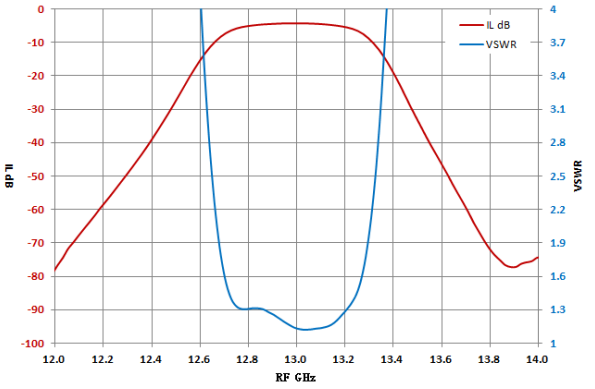


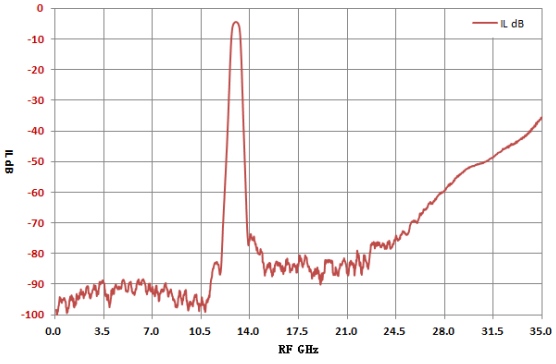
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

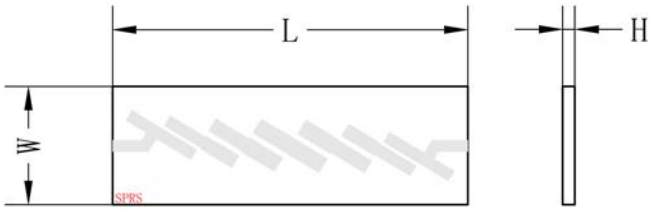
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	13.0	GHz
中心损耗	7.1	dB
驻波比	1.7:1	
带外抑制	35@DC-12.3GHz	dBc
带外抑制	40@13.6-21.0GHz	dBc

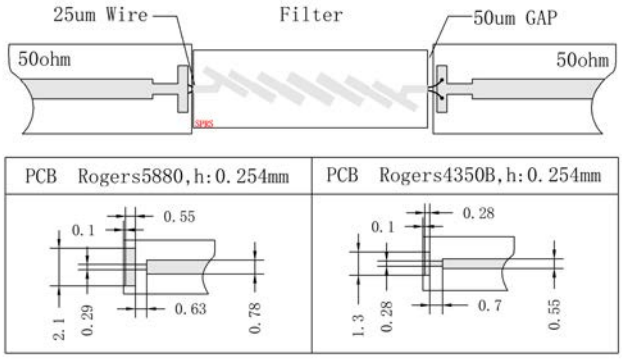
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



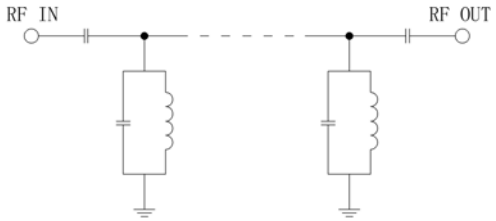
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.74mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

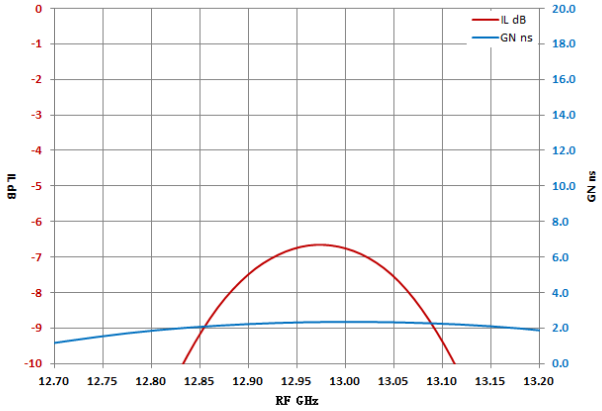
参考实物图

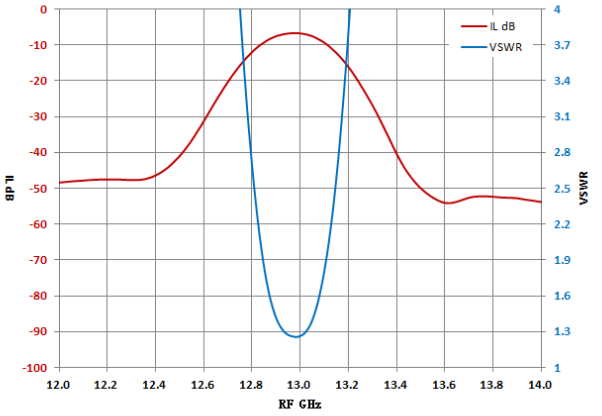


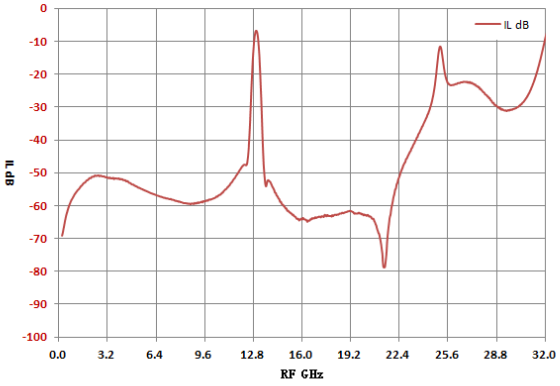
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



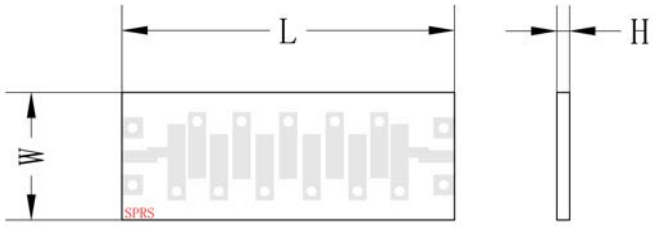
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	13.8	GHz
工作带宽	13.0-14.6	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-11.4GHz	dBc
带外抑制	40@16.4-31.0GHz	dBc

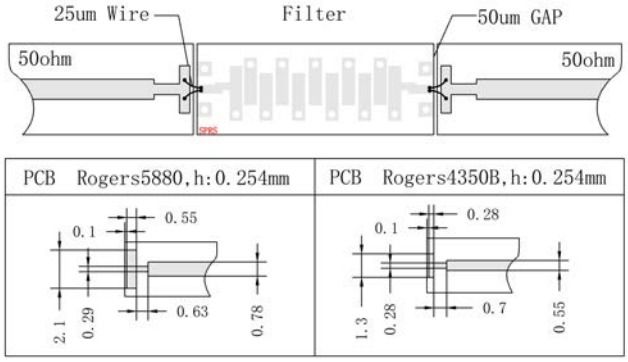
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



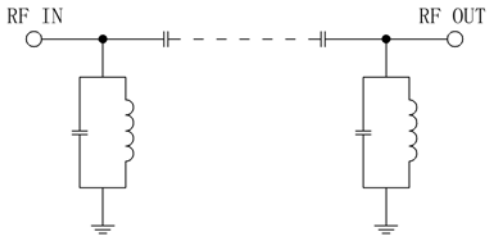
推荐装配图



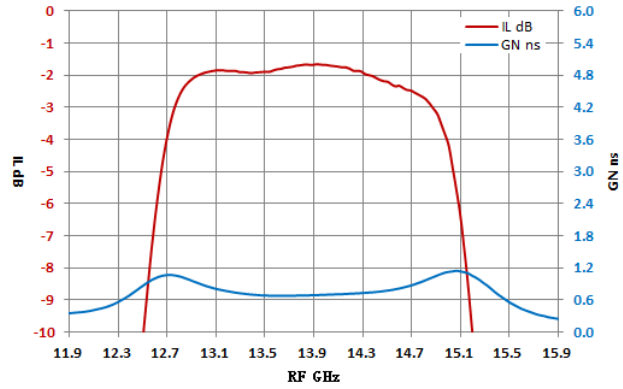
注意事项

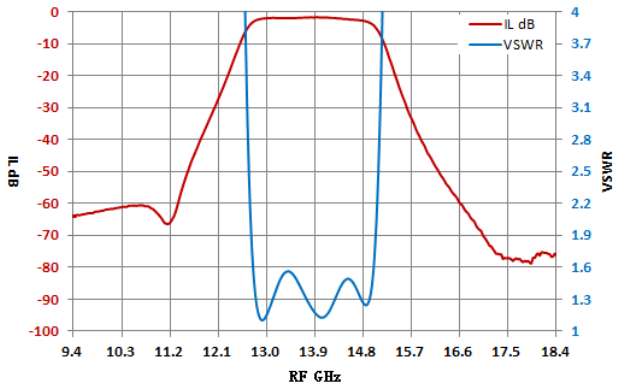
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

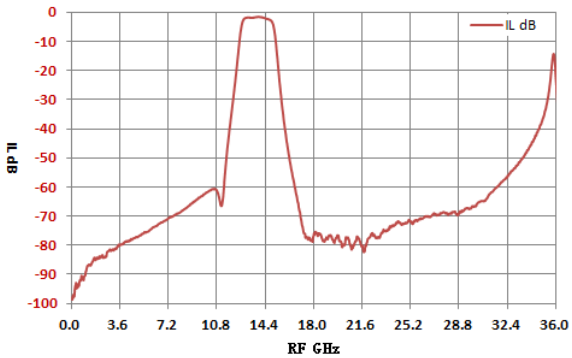
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



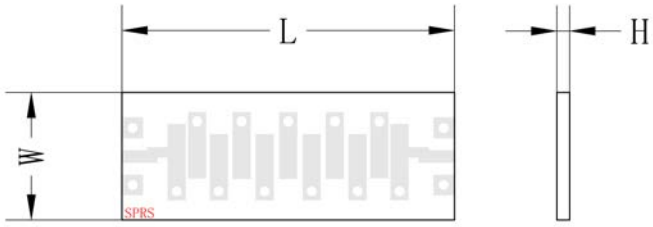
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	13.7	GHz
工作带宽	13.1-14.3	GHz
中心损耗	3.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-12.0GHz	dBc
带外抑制	40@15.4-32.0GHz	dBc

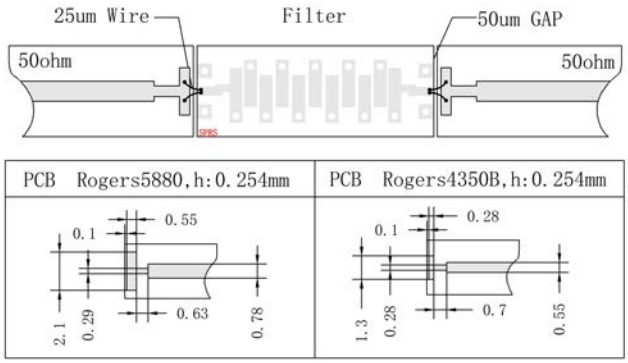
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



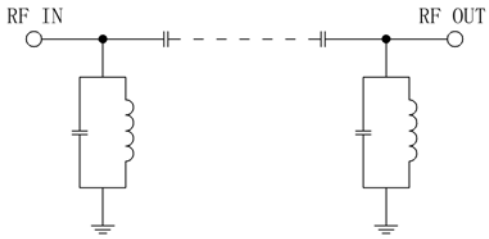
推荐装配图



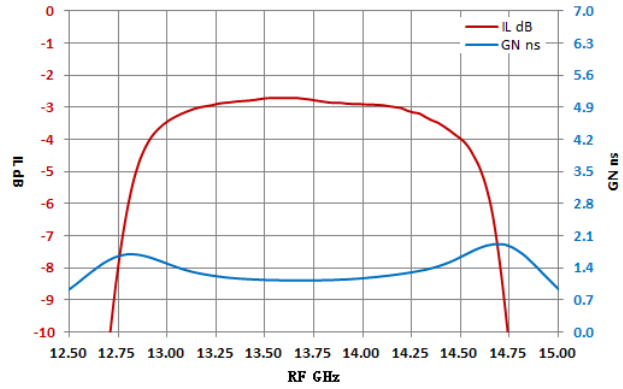
注意事项

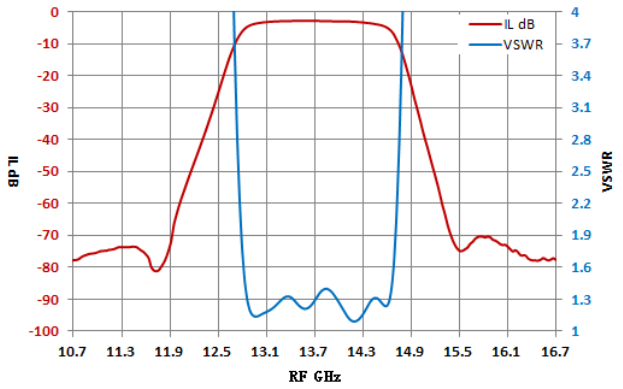
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

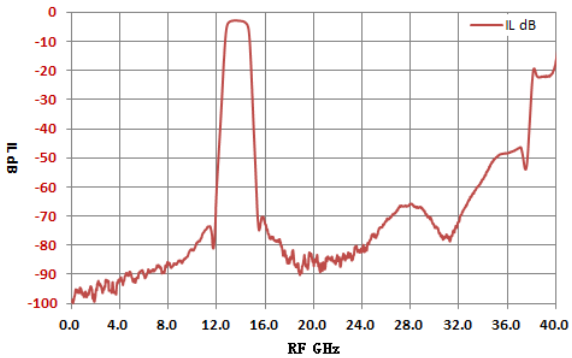
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



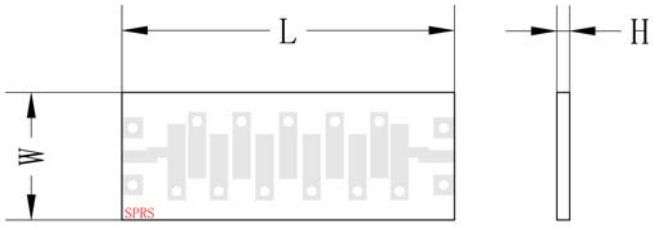
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	13.8	GHz
工作带宽	13.1-14.4	GHz
中心损耗	3.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.6	ns
带外抑制	40@DC-12.1GHz	dBc
带外抑制	40@15.6-31.0GHz	dBc

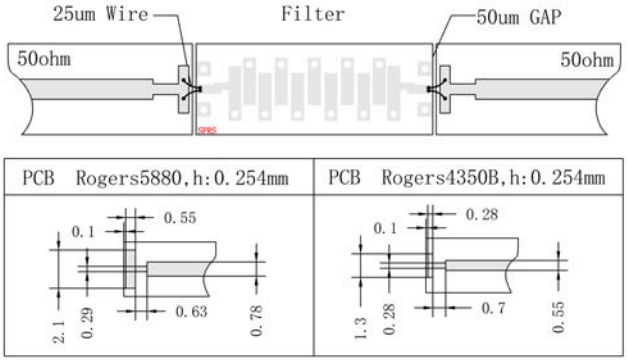
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：10.0，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



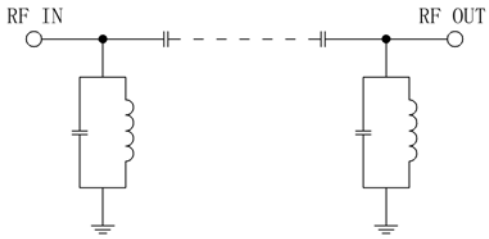
推荐装配图



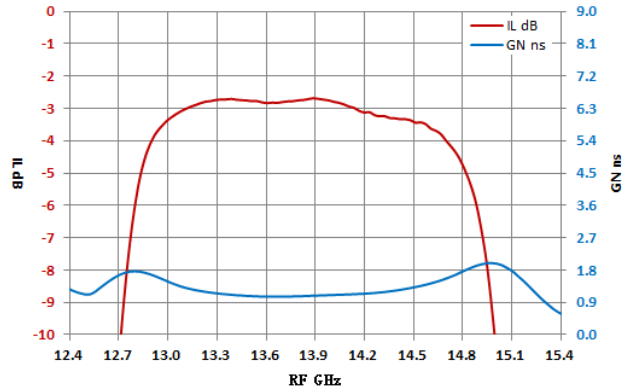
注意事项

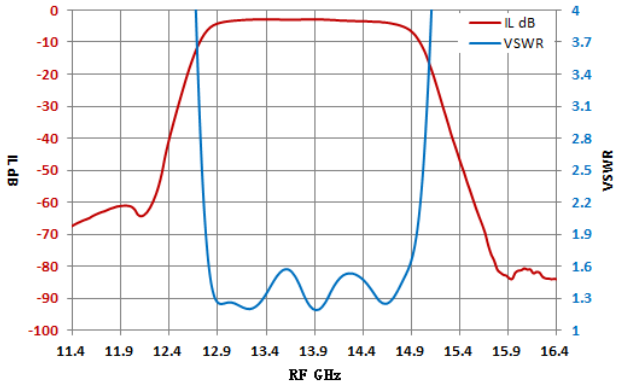
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

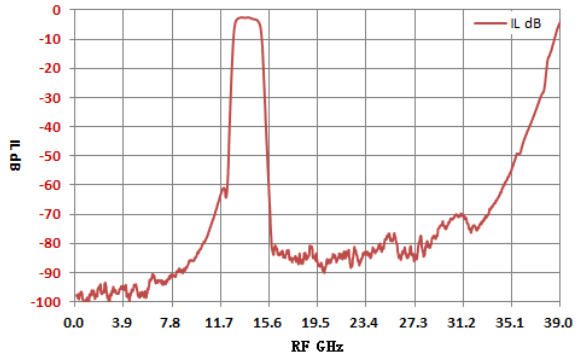
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

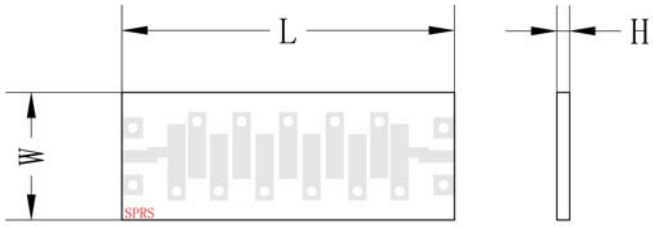
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	14.1	GHz
工作带宽	13.1-15.1	GHz
中心损耗	2.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-11.4GHz	dBc
带外抑制	40@17.4-33.0GHz	dBc

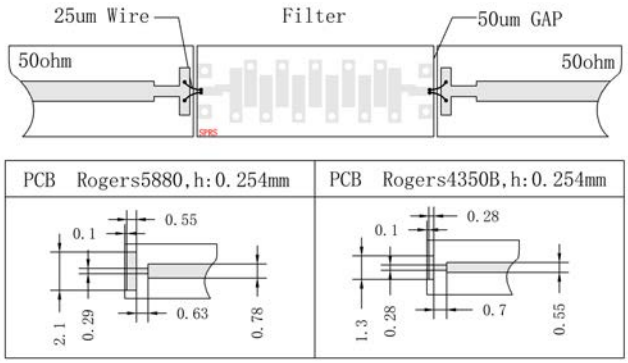
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



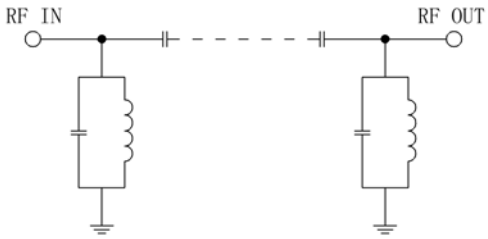
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.74mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

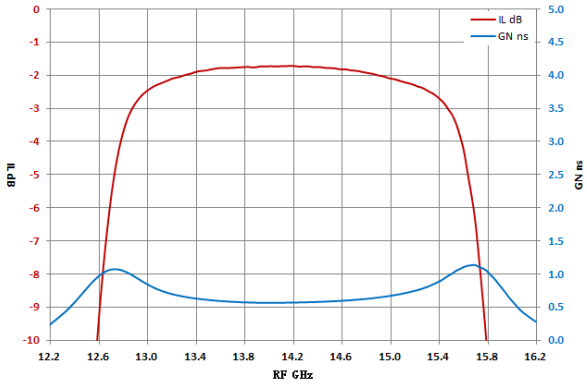
参考实物图

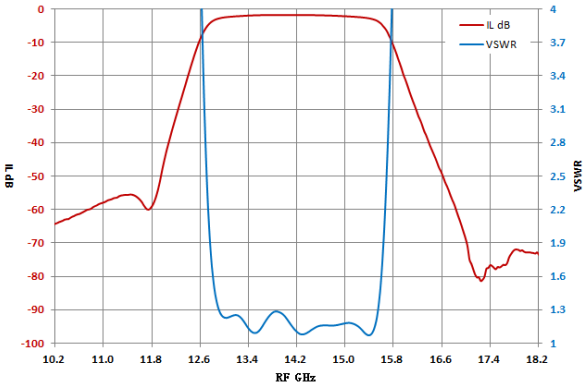


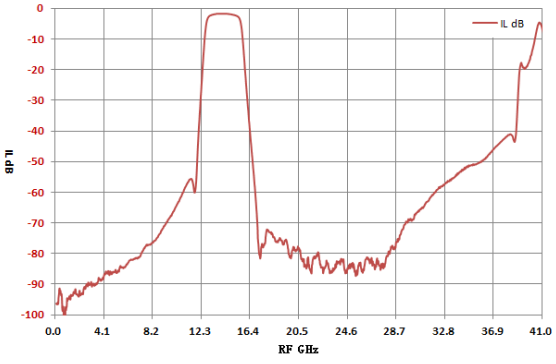
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

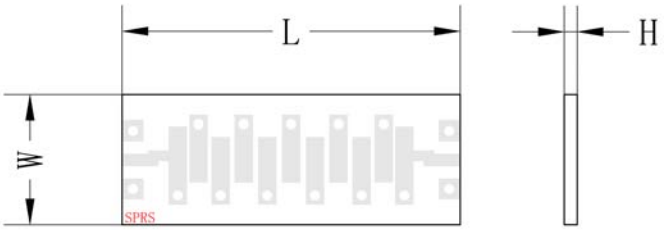
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	13.5	GHz
工作带宽	13.2-13.8	GHz
中心损耗	2.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-12.0GHz	dBc
带外抑制	40@15.2-24.0GHz	dBc

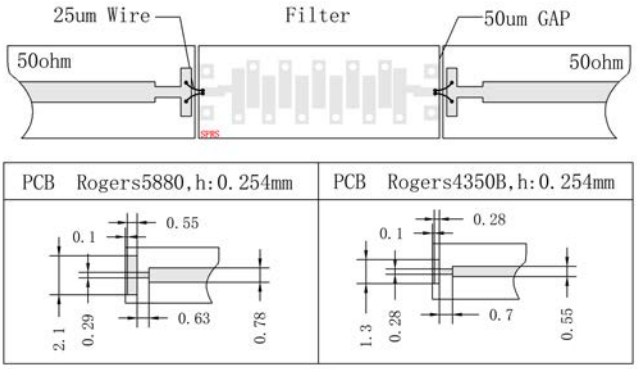
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：4.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

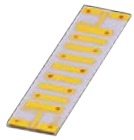
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

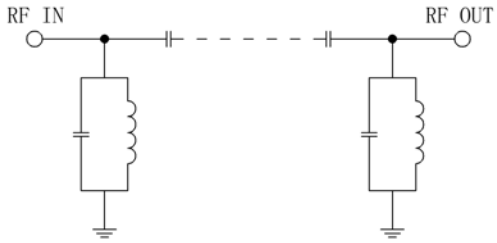
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

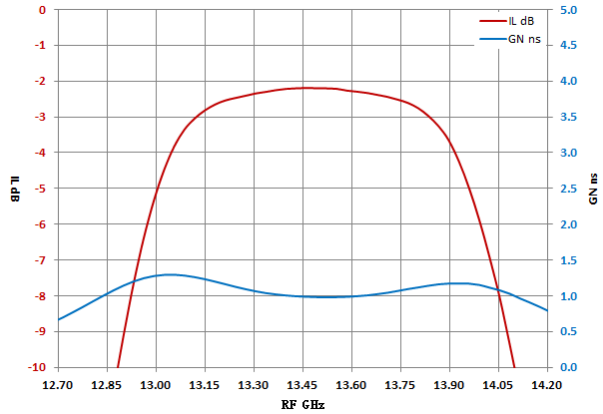
参考图

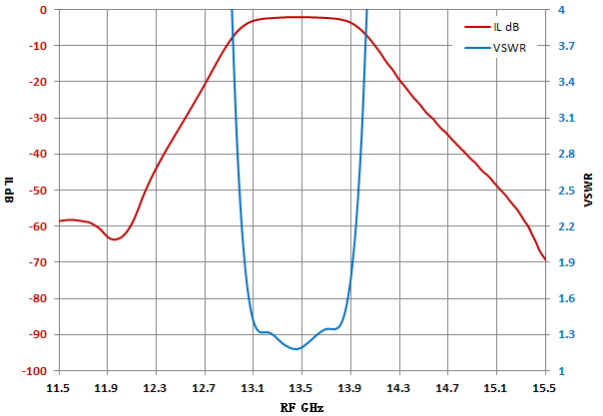


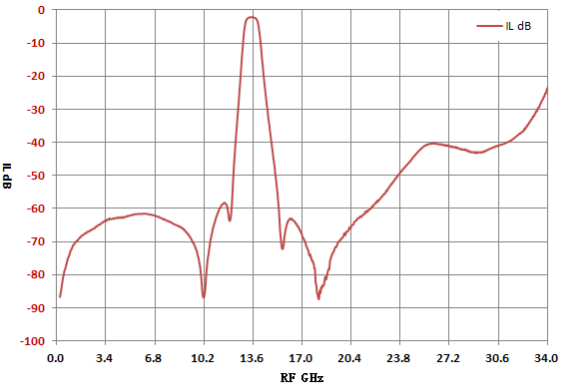
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

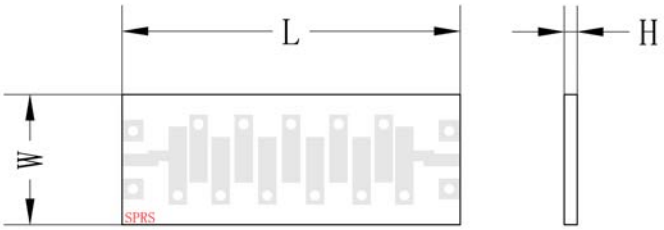
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	13.7	GHz
工作带宽	13.2-14.2	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	50@DC-10.5GHz	dBc
带外抑制	50@17.5-19.0GHz	dBc

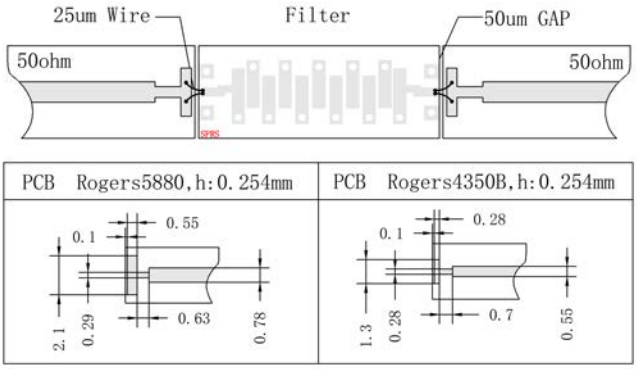
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：4.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.74mm,端口可互换;

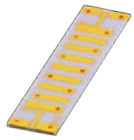
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

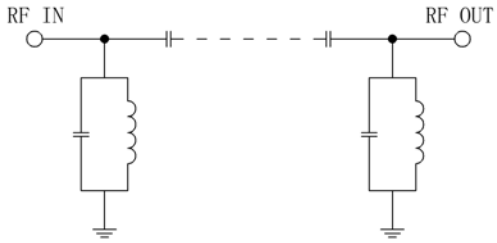
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

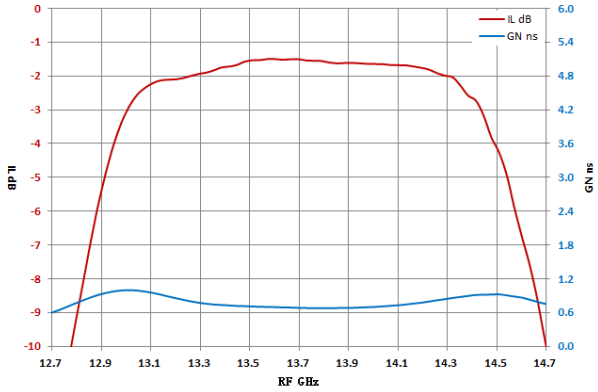
参考图

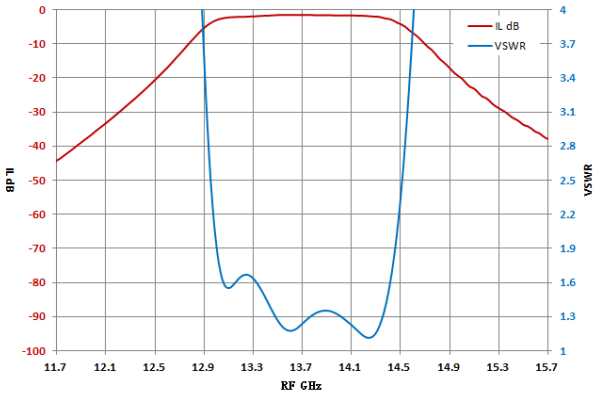


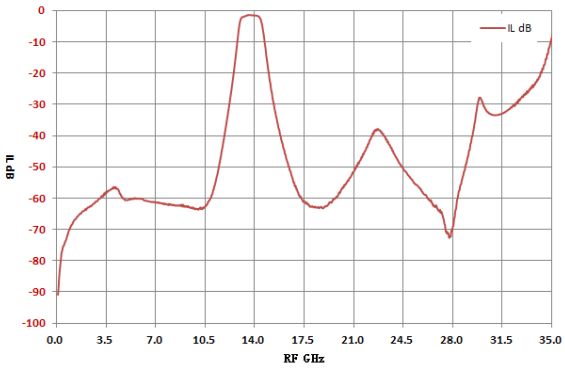
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



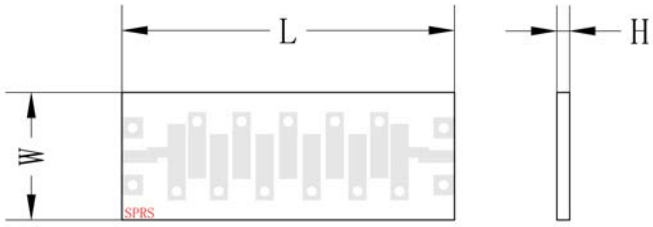
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	16.5	GHz
工作带宽	13.2-19.8	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-11.0GHz	dBc
带外抑制	40@22.8-37.0GHz	dBc

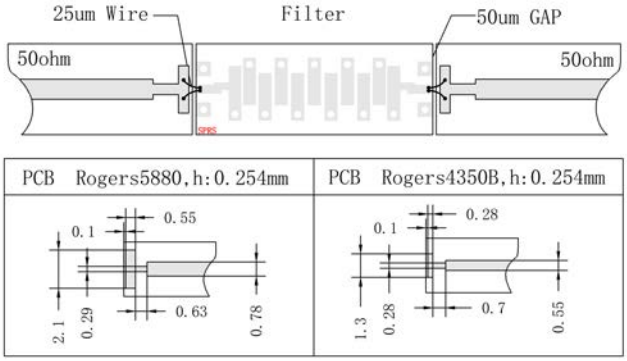
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



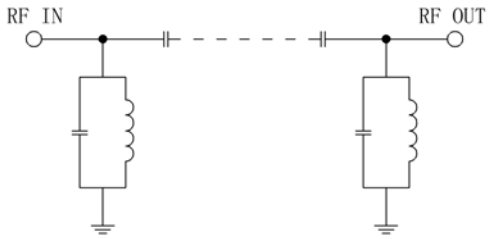
推荐装配图



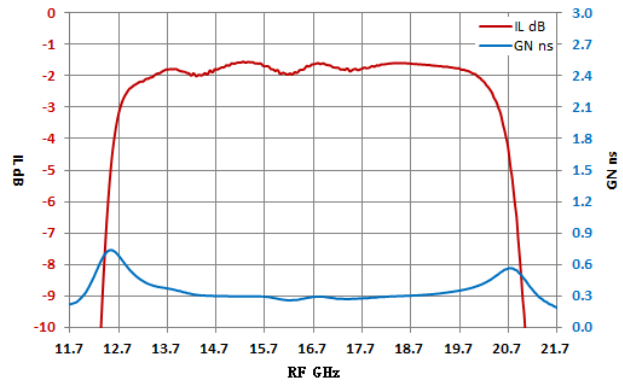
注意事项

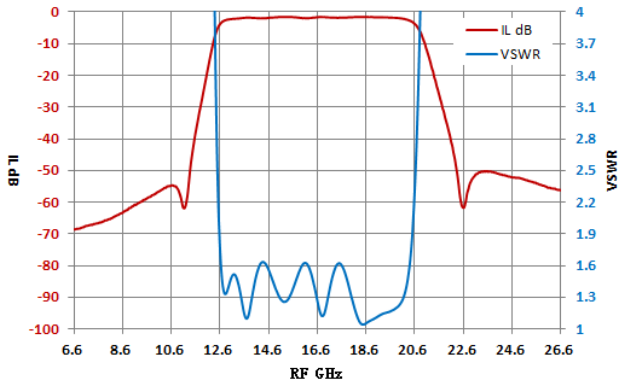
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

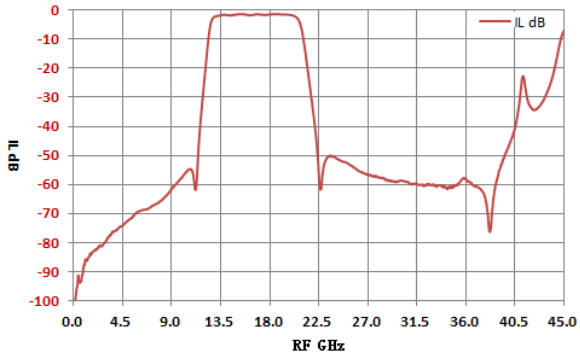
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

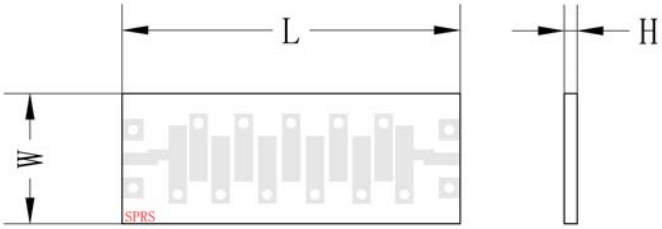
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	14.65	GHz
工作带宽	13.3-16.0	GHz
中心损耗	2.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-11.6GHz	dBc
带外抑制	40@17.5-37.0GHz	dBc

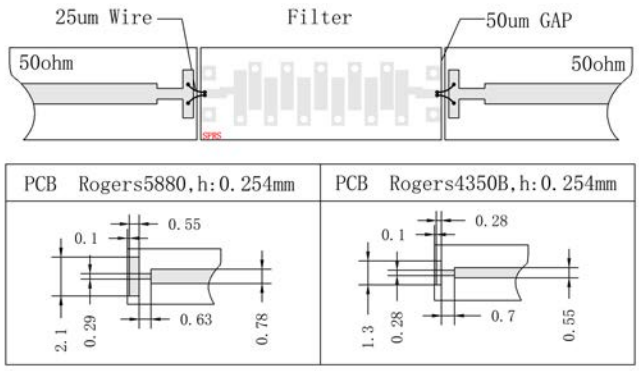
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：7.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

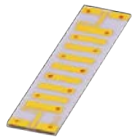
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

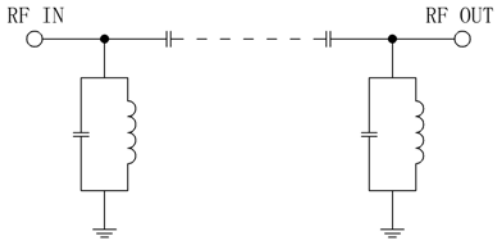
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

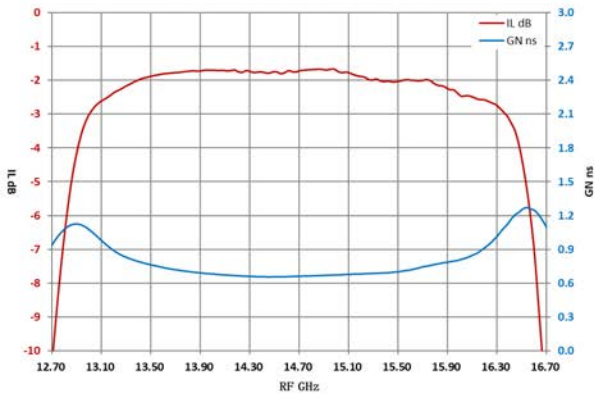
参考图

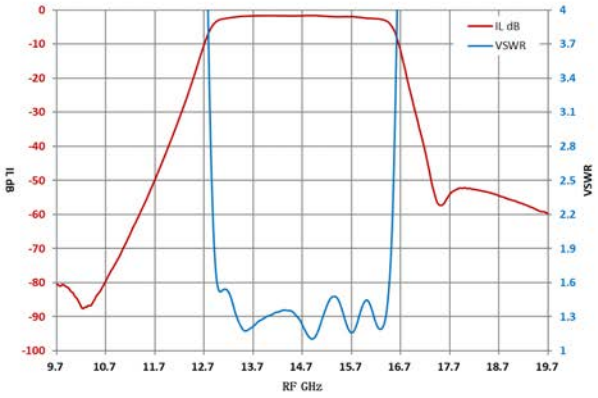


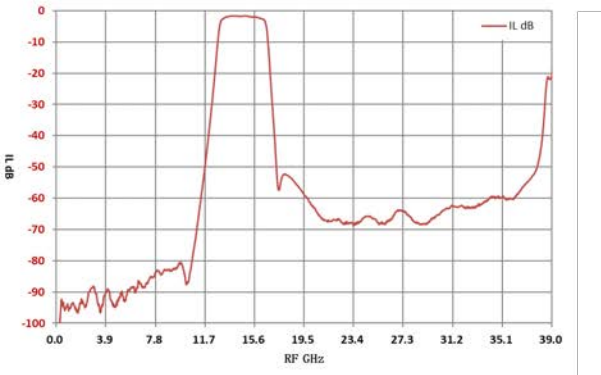
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



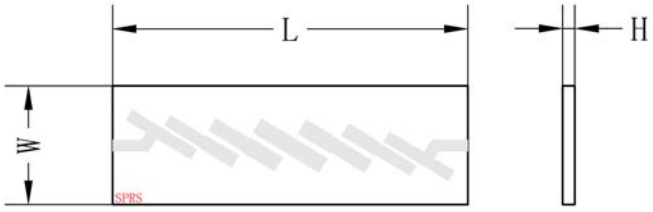
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	13.4	GHz
工作带宽	0	GHz
中心损耗	6.8	dB
带内波动	0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0	ns
带外抑制	35@DC-12.8GHz	dBc
带外抑制	35@14.0-22.0GHz	dBc

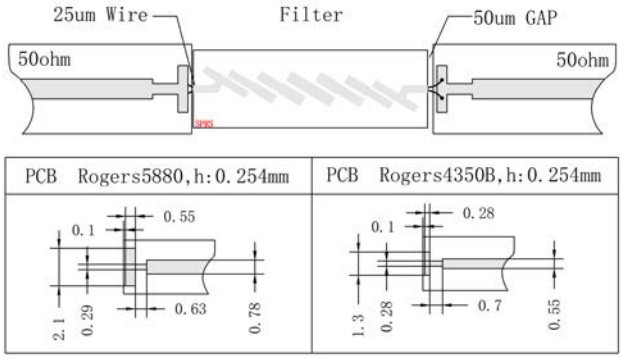
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



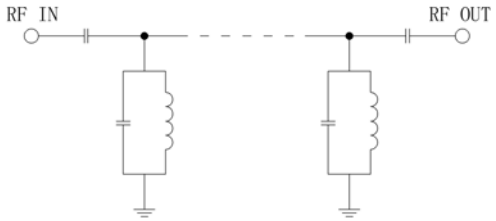
推荐装配图



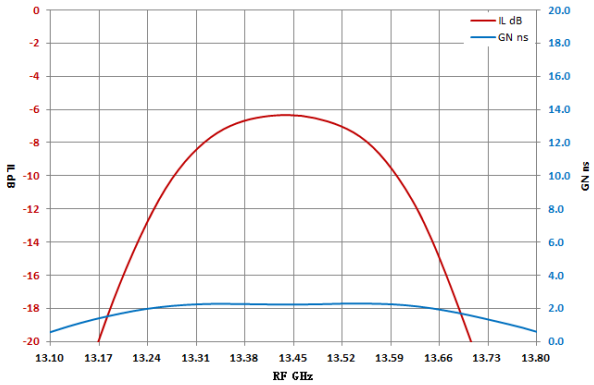
注意事项

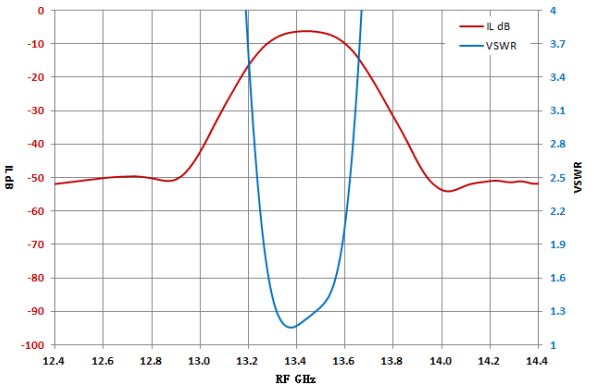
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

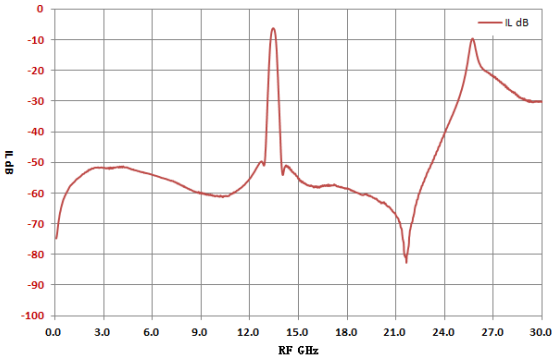
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

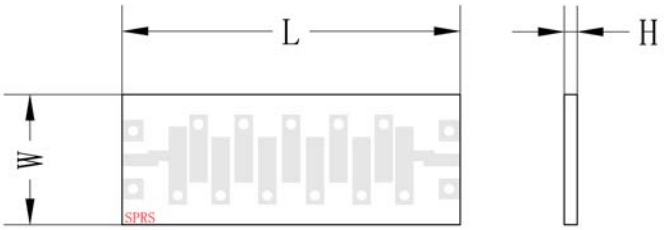
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	14.05	GHz
工作带宽	13.4-14.7	GHz
中心损耗	3.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-12.5GHz	dBc
带外抑制	40@15.5-34.0GHz	dBc

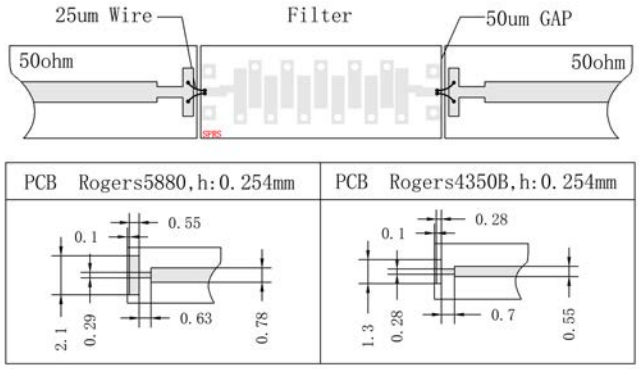
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：8.0，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.74mm,端口可互换;

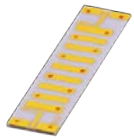
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

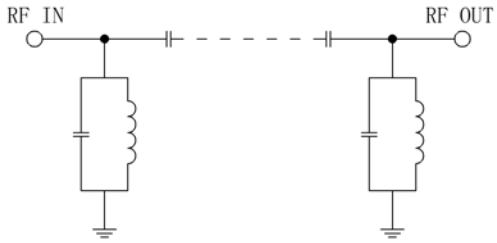
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

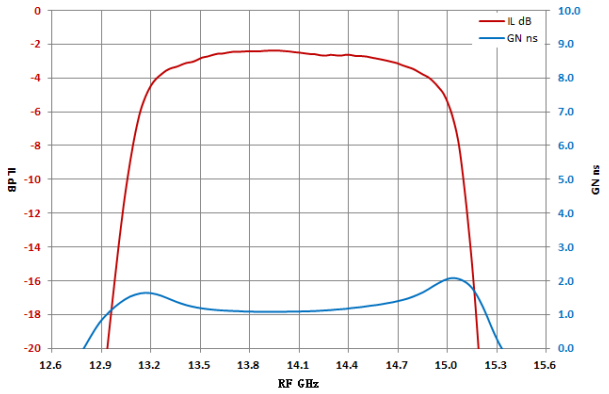
参考图

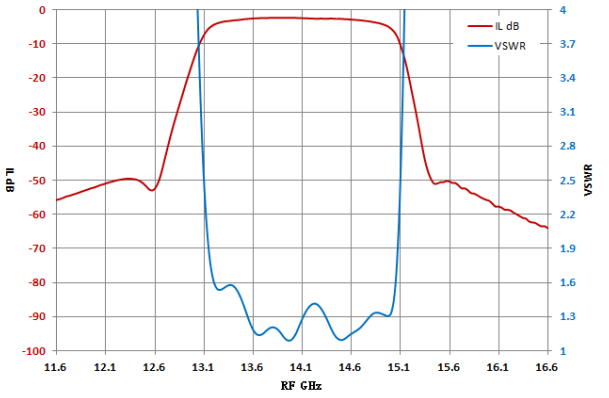


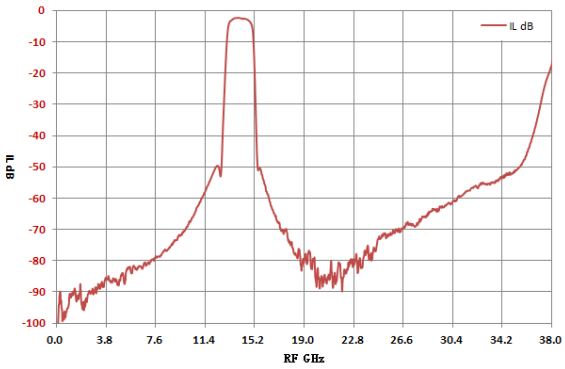
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



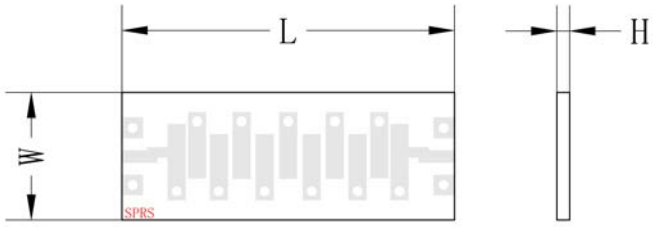
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	14.1	GHz
工作带宽	13.4-14.8	GHz
中心损耗	2.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-12.2GHz	dBc
带外抑制	40@16.1-35.0GHz	dBc

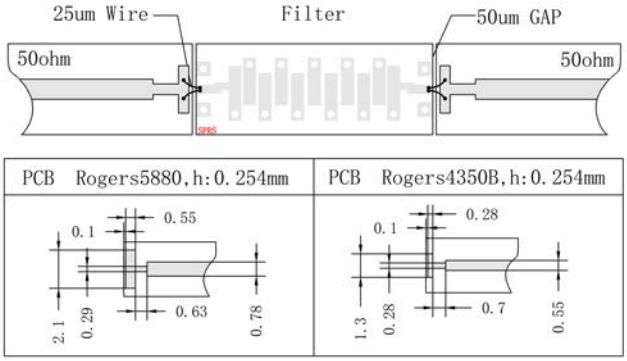
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



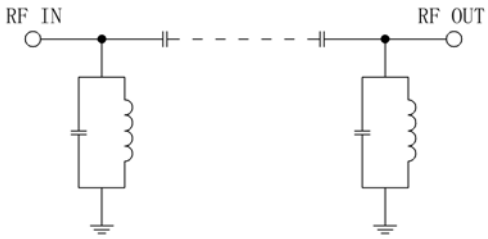
推荐装配图



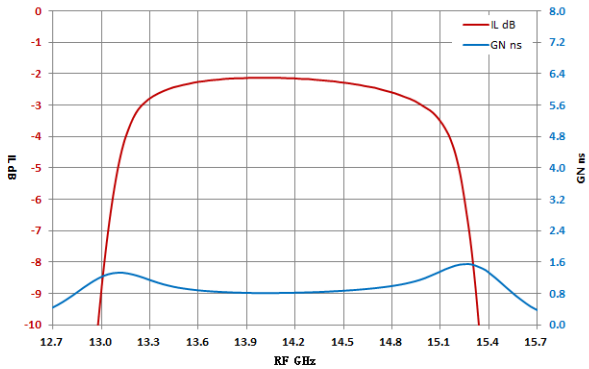
注意事项

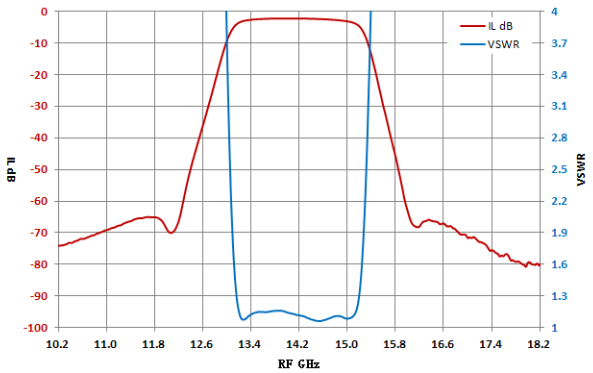
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

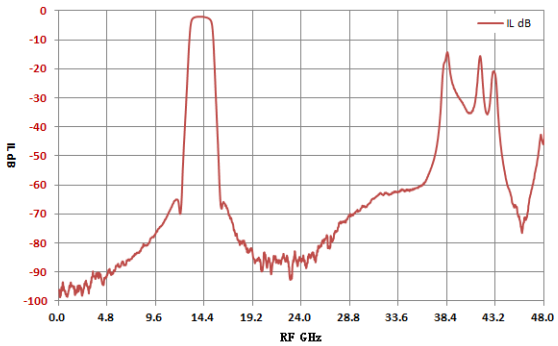
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

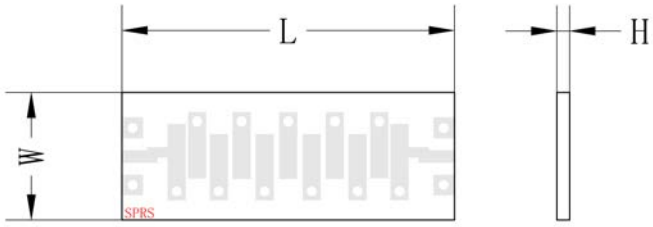
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	14.85	GHz
工作带宽	13.4-16.3	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-11.2GHz	dBc
带外抑制	40@19.2-33.0GHz	dBc

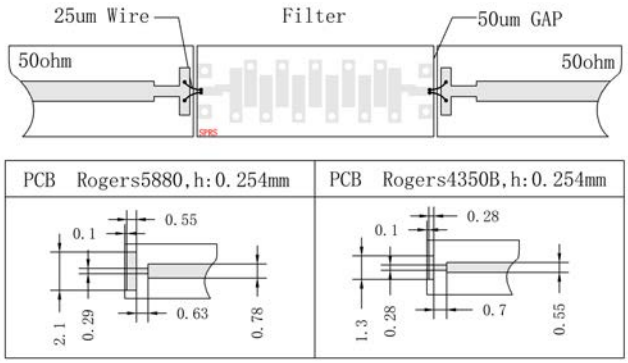
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：3.2，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



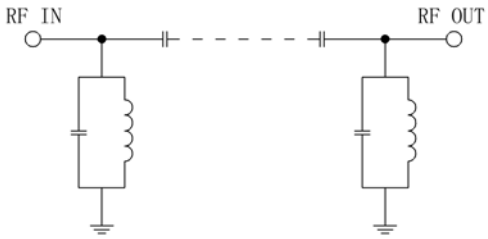
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.87mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

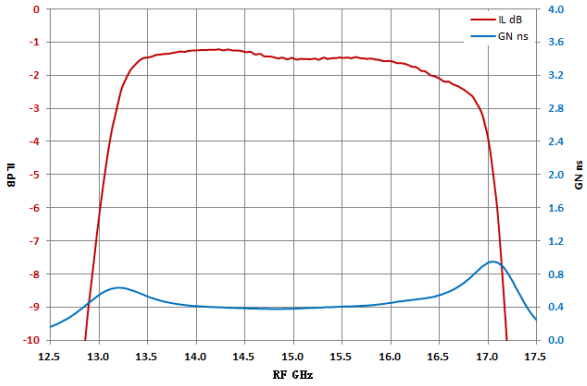
参考实物图

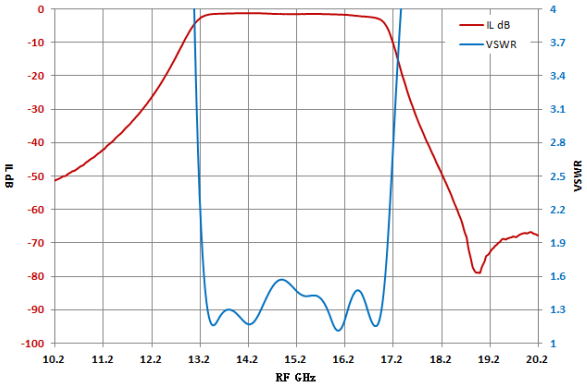


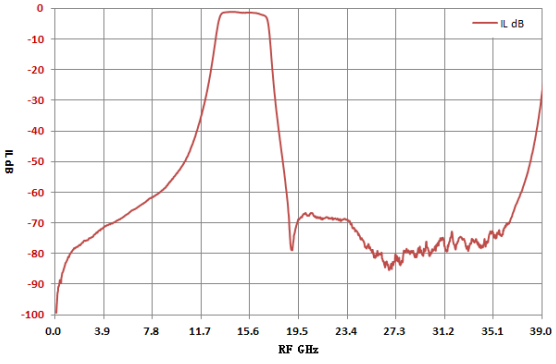
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



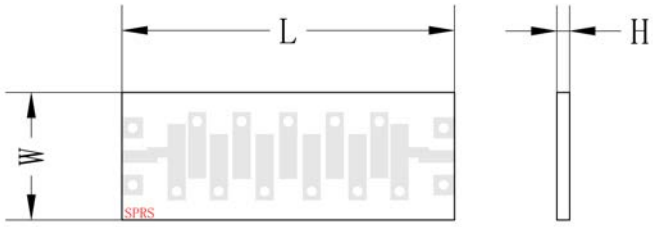
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	16.0	GHz
工作带宽	13.4-18.6	GHz
中心损耗	1.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-10.7GHz	dBc
带外抑制	40@20.7-37.0GHz	dBc

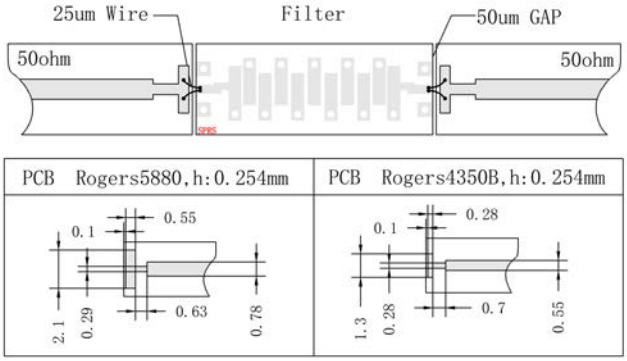
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



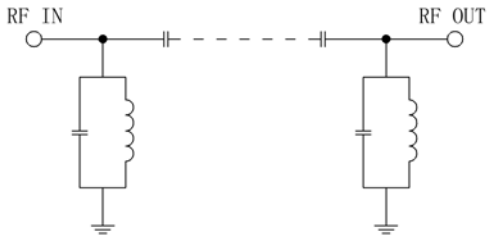
推荐装配图



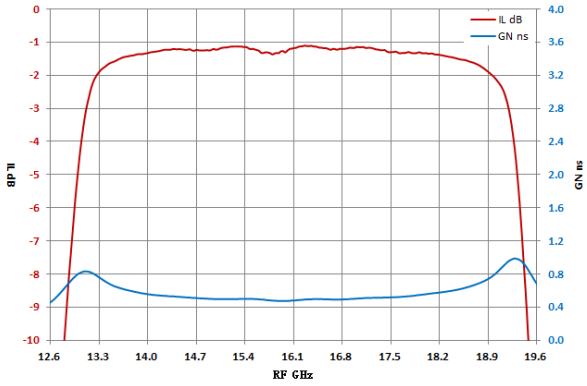
注意事项

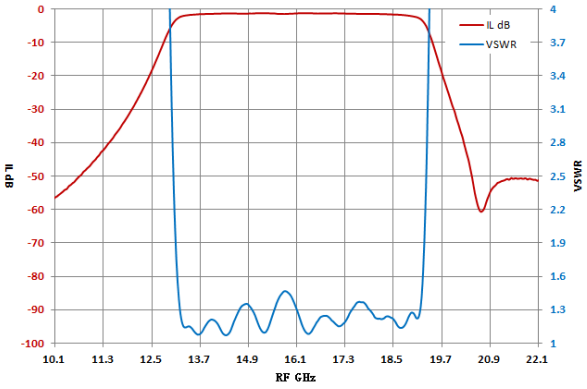
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

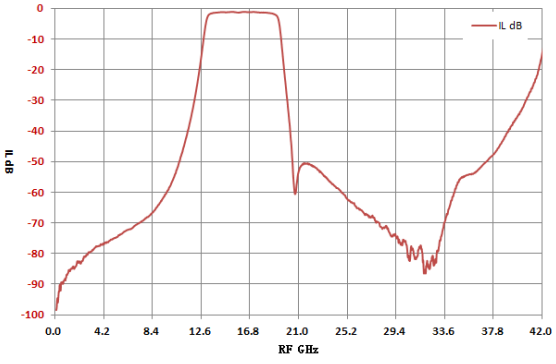
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

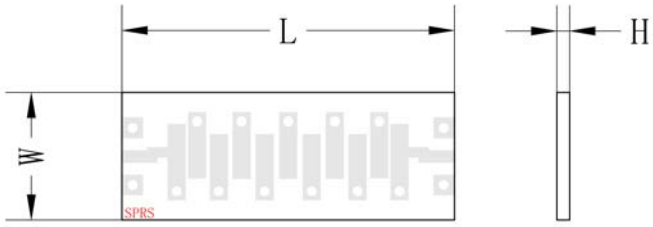
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	16.3	GHz
工作带宽	13.4-19.2	GHz
中心损耗	1.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-10.1GHz	dBc
带外抑制	40@21.3-38.7GHz	dBc

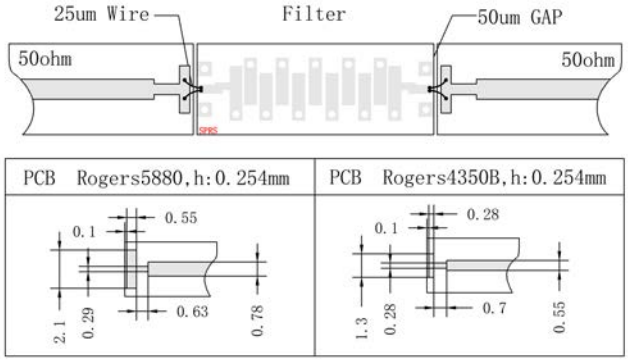
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



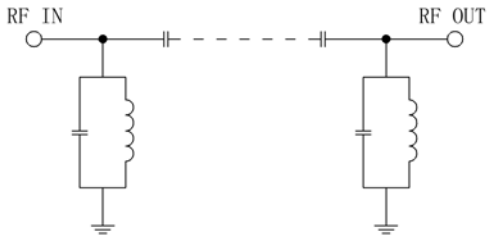
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

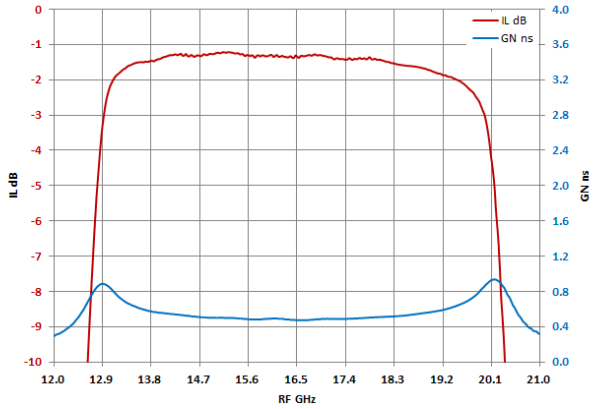
参考实物图

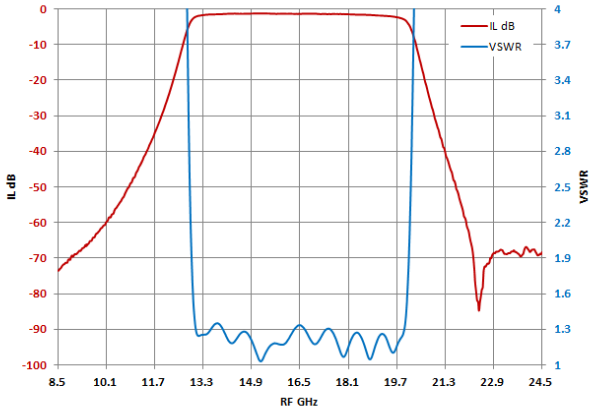


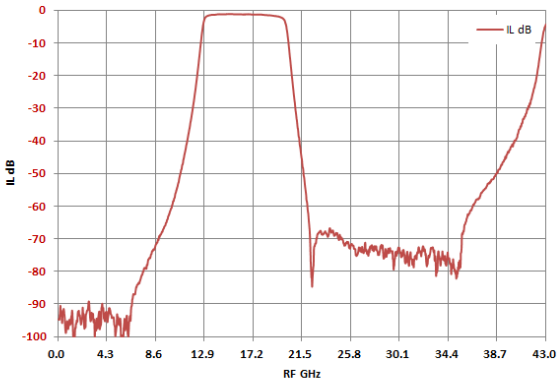
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



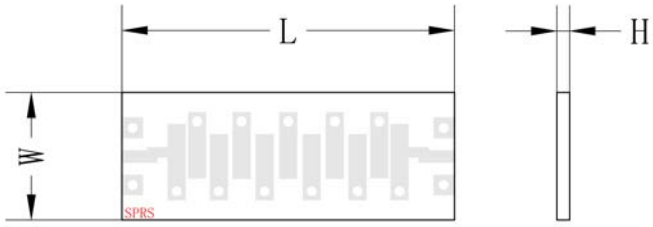
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	17.1	GHz
工作带宽	13.4-20.8	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-9.6GHz	dBc
带外抑制	40@23.8-40.0GHz	dBc

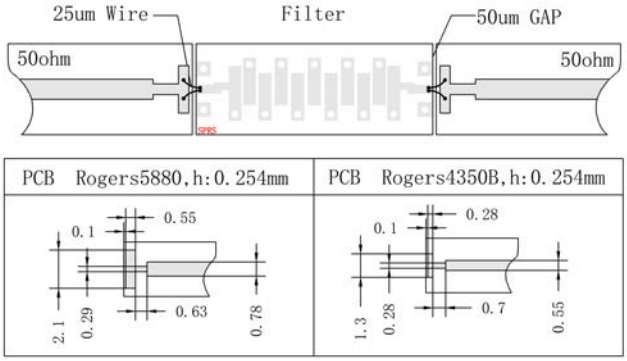
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



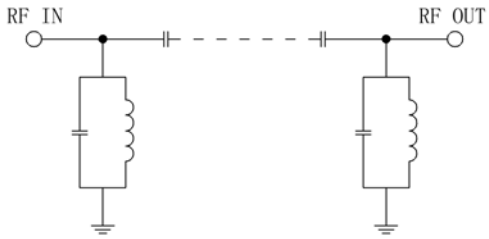
推荐装配图



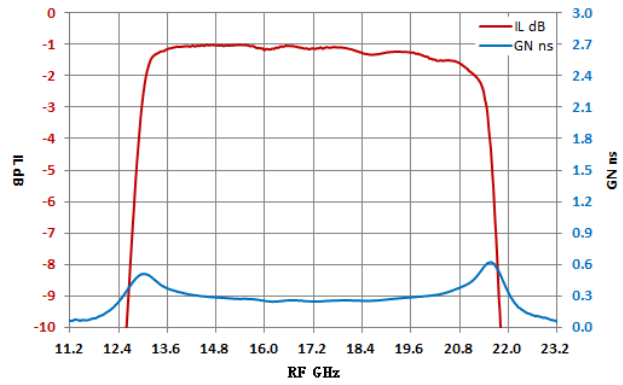
注意事项

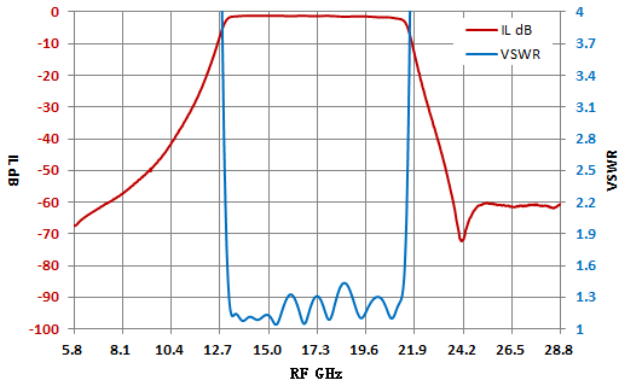
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

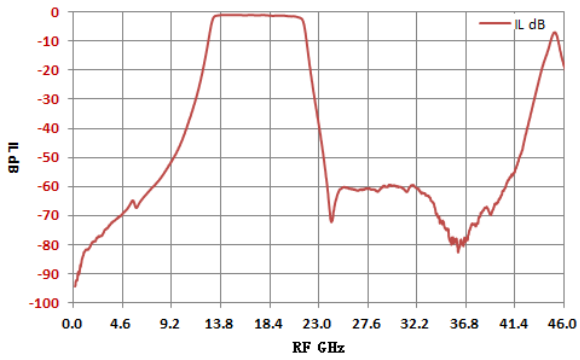
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



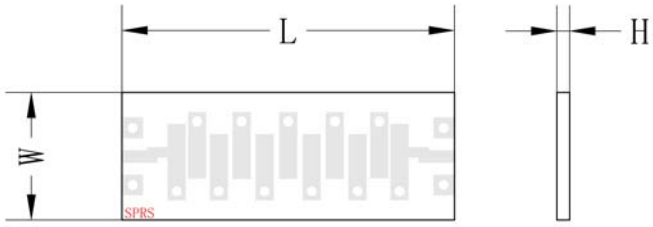
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	14.3	GHz
工作带宽	13.5-15.1	GHz
中心损耗	3.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	1.0	ns
带外抑制	40@DC-12.3GHz	dBc
带外抑制	40@16.4-32.0GHz	dBc

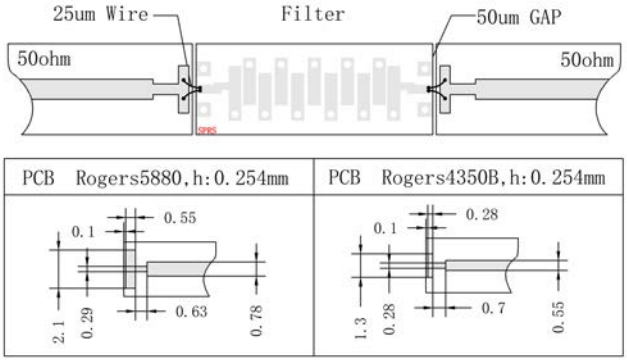
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



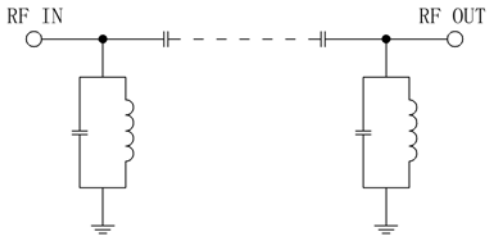
推荐装配图



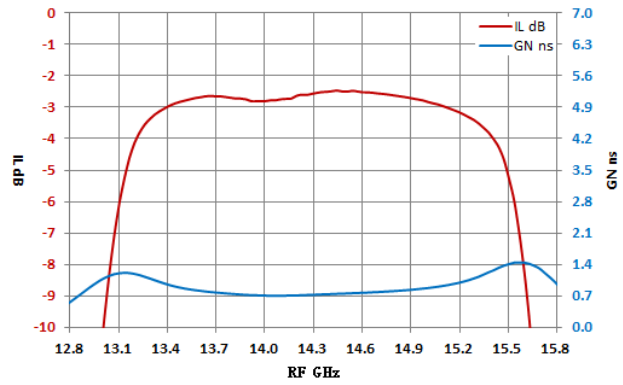
注意事项

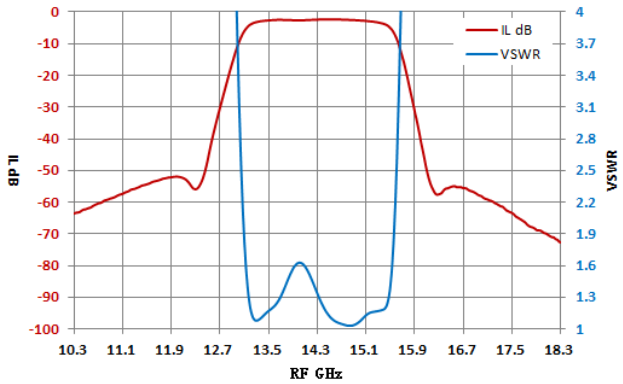
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

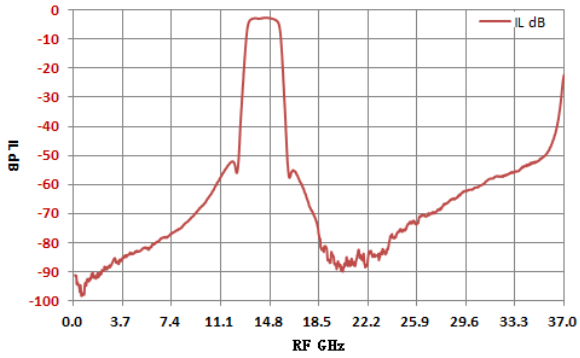
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

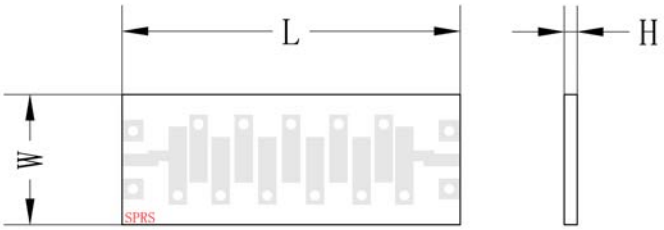
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	14.4	GHz
工作带宽	13.5-15.3	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-12.2GHz	dBc
带外抑制	40@16.7-31.0GHz	dBc

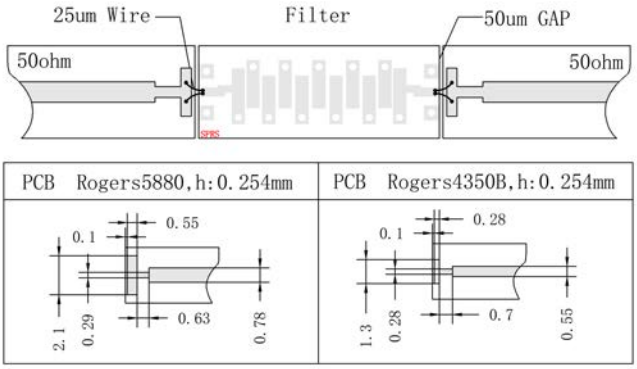
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

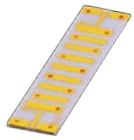
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

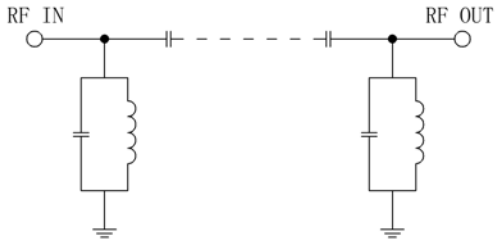
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

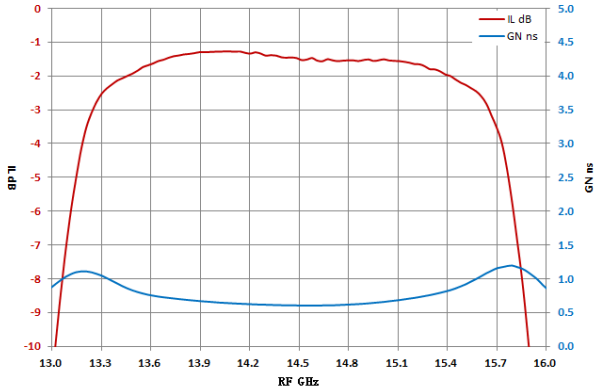
参考图

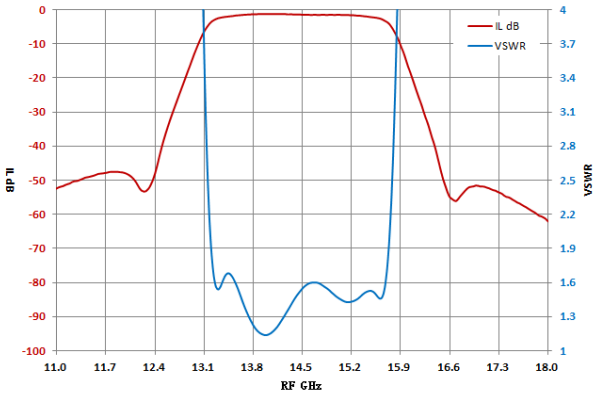


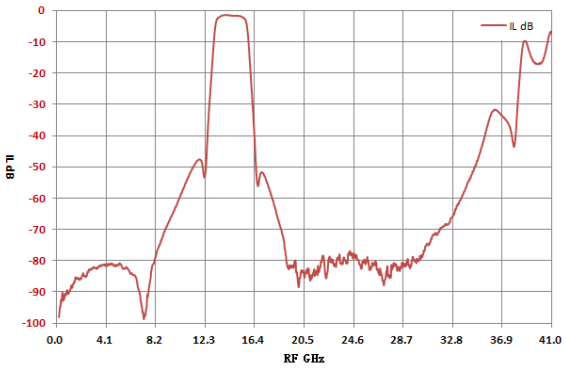
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



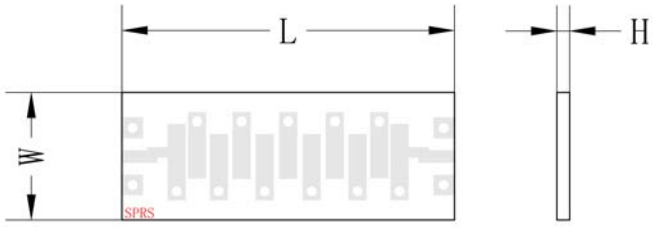
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	16.0	GHz
工作带宽	13.5-18.5	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-11.2GHz	dBc
带外抑制	40@20.2-36.0GHz	dBc

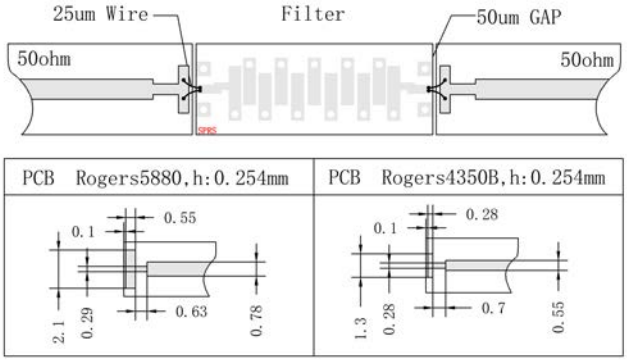
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



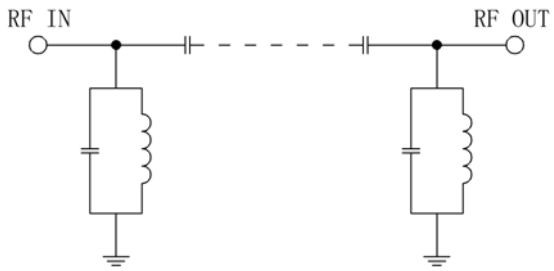
推荐装配图



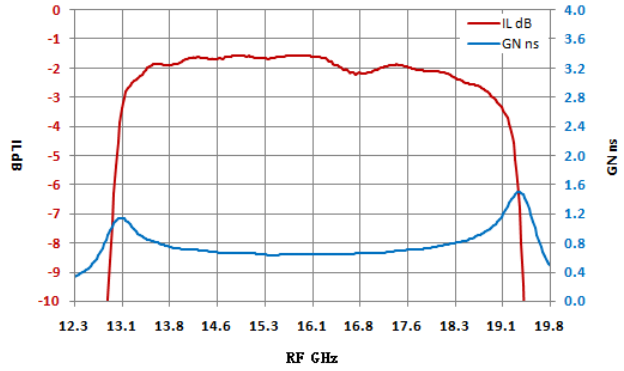
注意事项

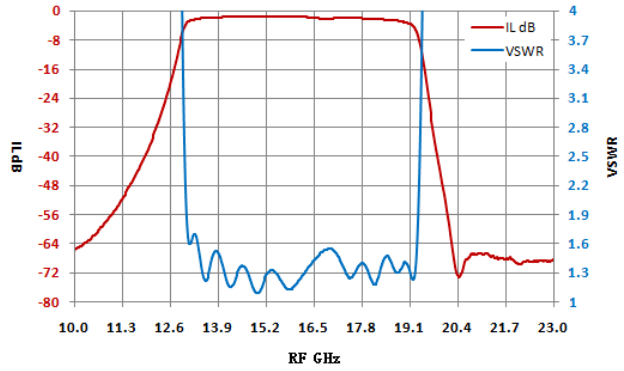
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

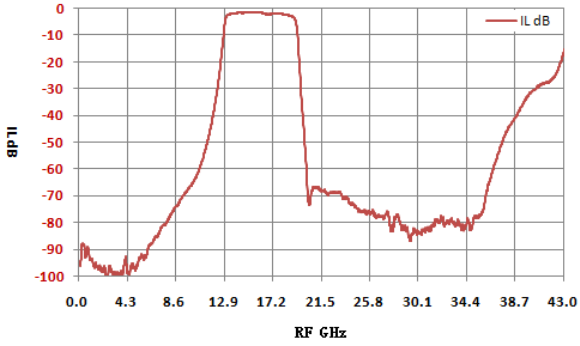
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

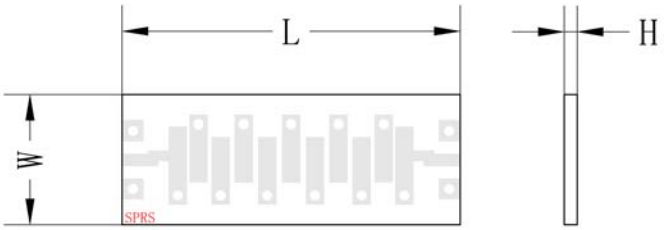
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	16.0	GHz
工作带宽	13.5-18.5	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	50@DC-10.6GHz	dBc
带外抑制	50@20.6-35.0GHz	dBc

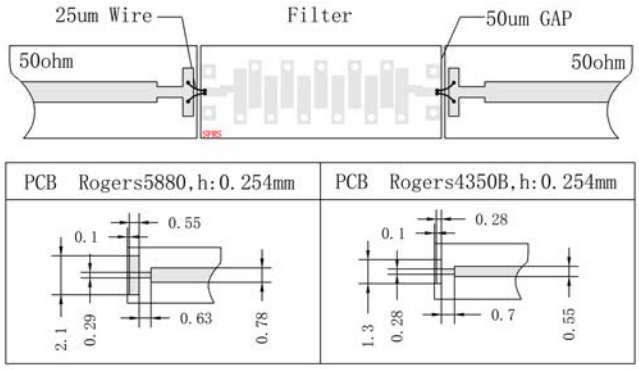
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：7.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

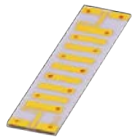
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

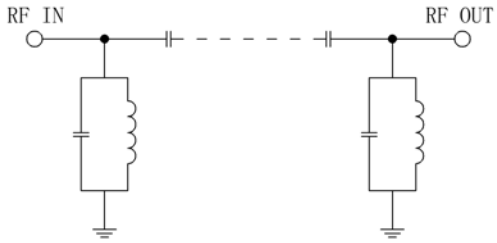
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

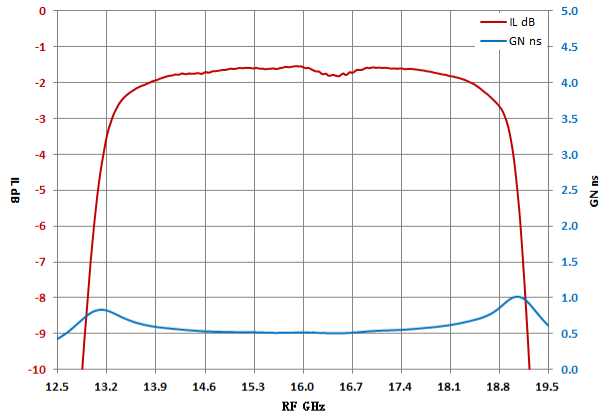
参考图

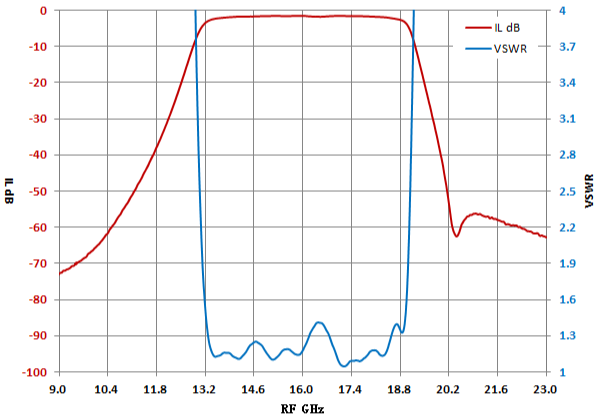


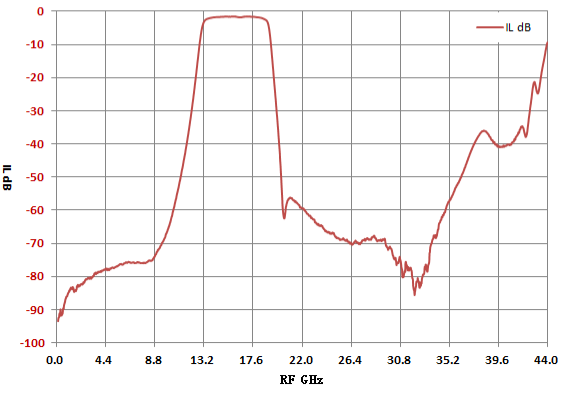
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



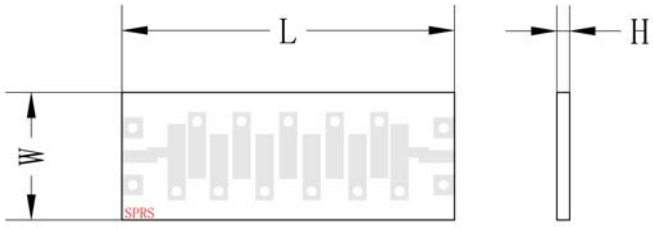
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	17.7	GHz
工作带宽	13.5-21.9	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-10.5GHz	dBc
带外抑制	40@24.8-40.0GHz	dBc

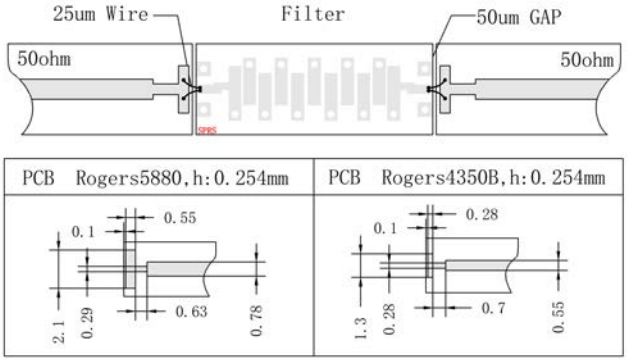
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



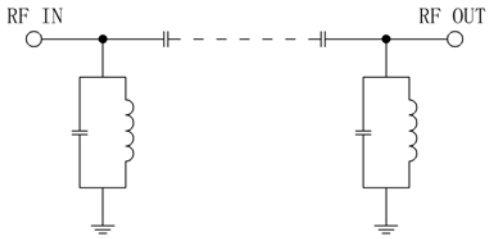
推荐装配图



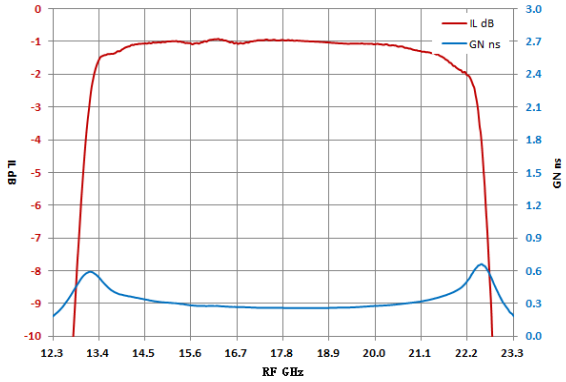
注意事项

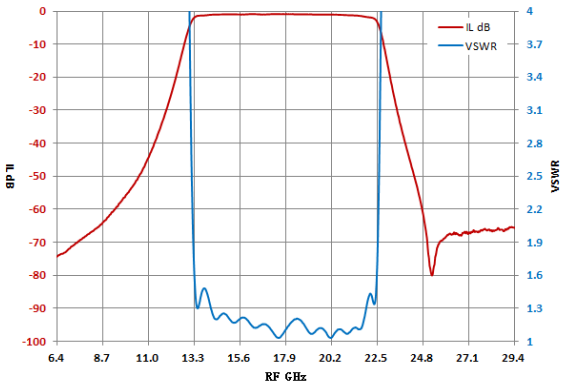
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

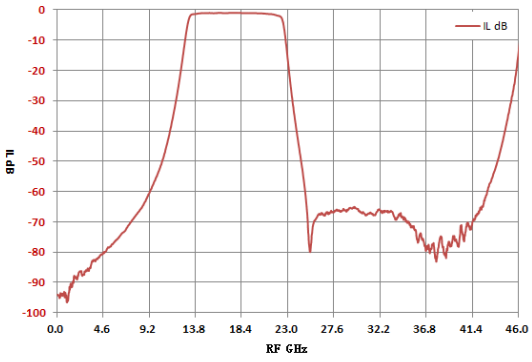
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

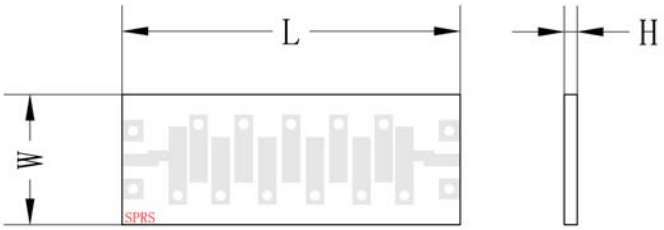
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	14.2	GHz
工作带宽	13.6-14.8	GHz
中心损耗	2.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	35@DC-12.2GHz	dBc
带外抑制	25@16.2-30.0GHz	dBc

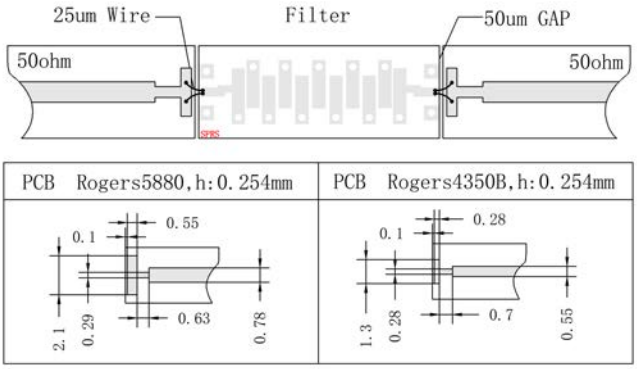
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：4.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.74mm,端口可互换;

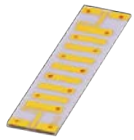
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

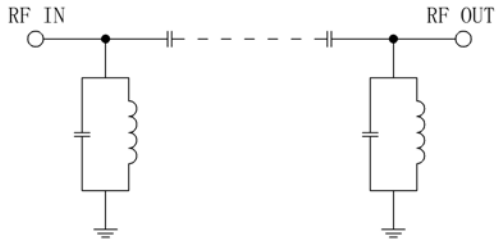
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

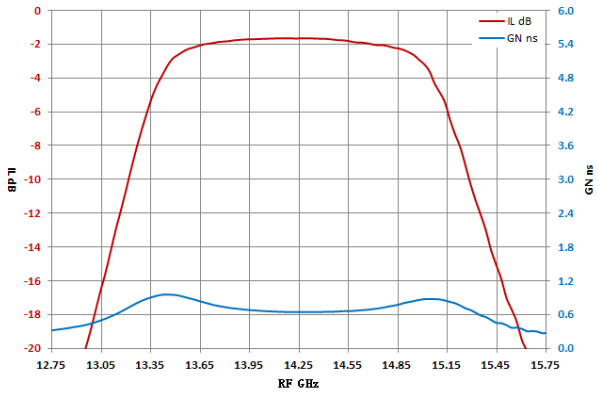
参考图

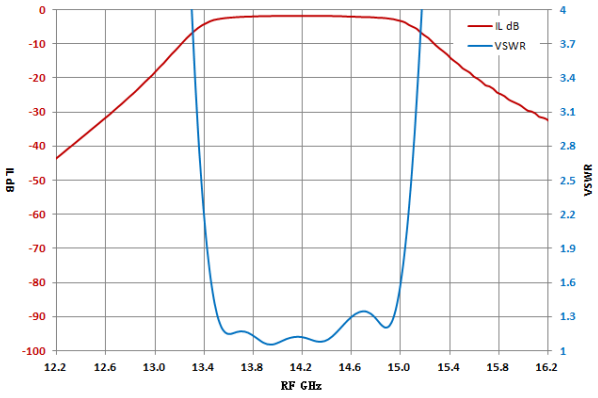


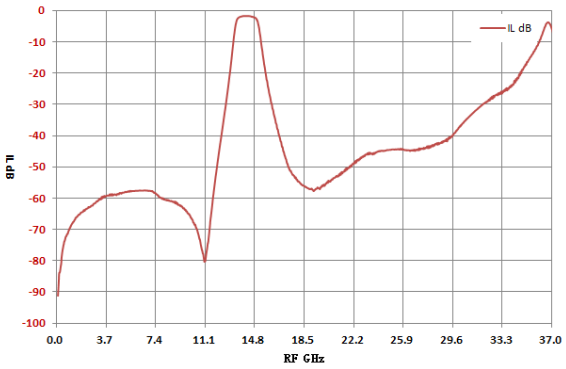
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



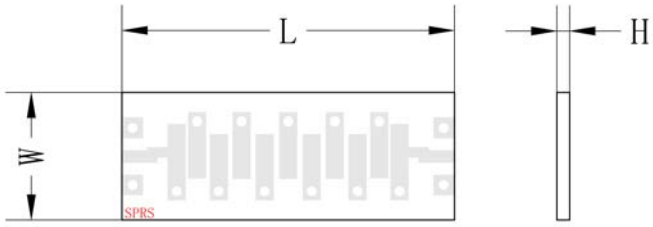
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	16.0	GHz
工作带宽	13.6-18.3	GHz
中心损耗	1.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-10.8GHz	dBc
带外抑制	40@20.2-37.0GHz	dBc

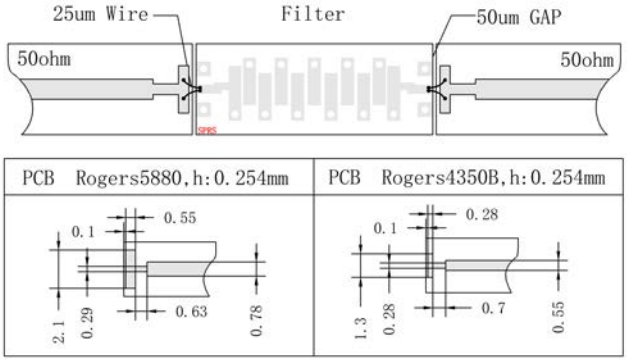
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



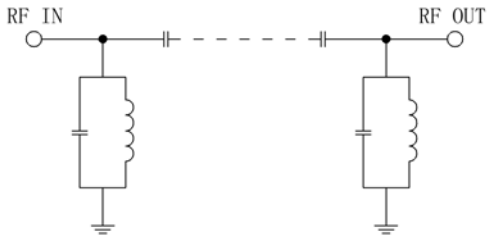
推荐装配图



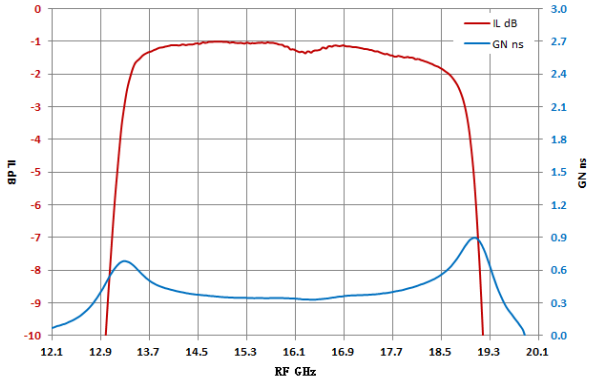
注意事项

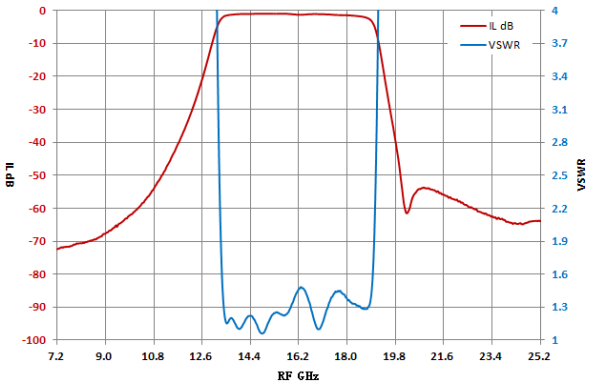
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

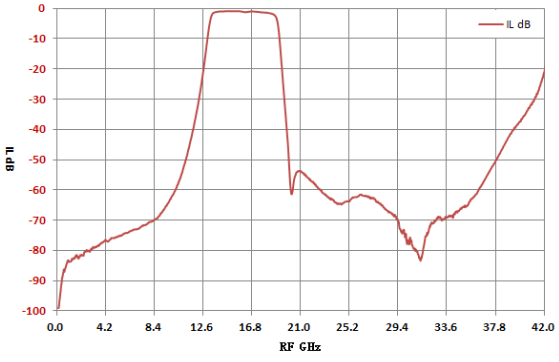
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

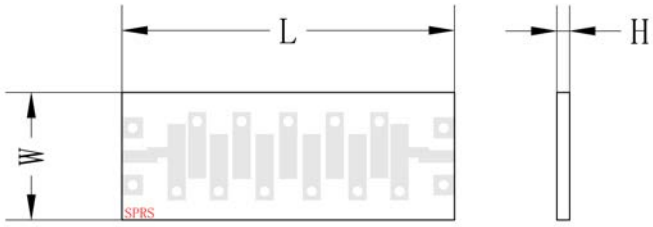
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	15.65	GHz
工作带宽	13.7-17.6	GHz
中心损耗	1.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-11.2GHz	dBc
带外抑制	40@21.0-34.0GHz	dBc

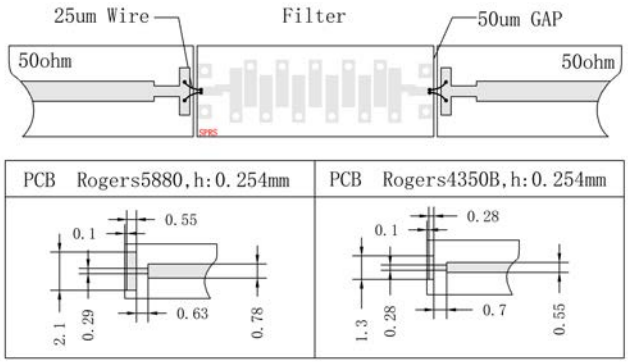
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



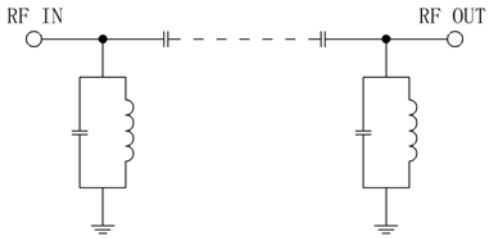
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

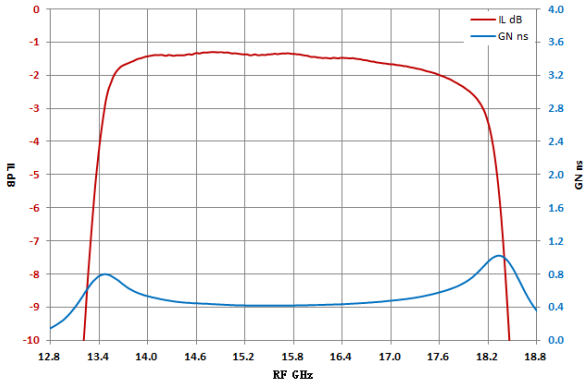
参考实物图

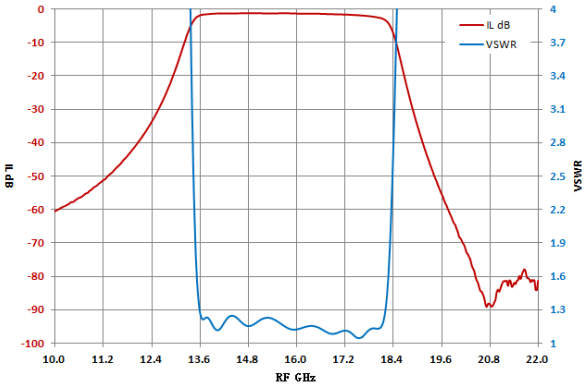


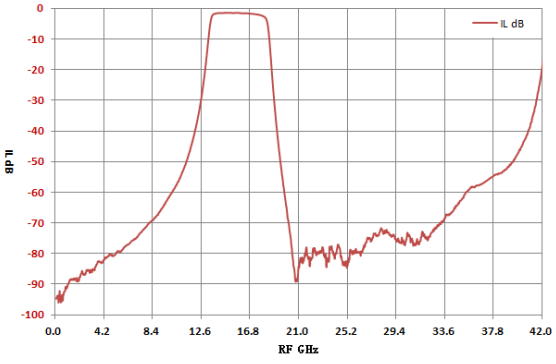
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

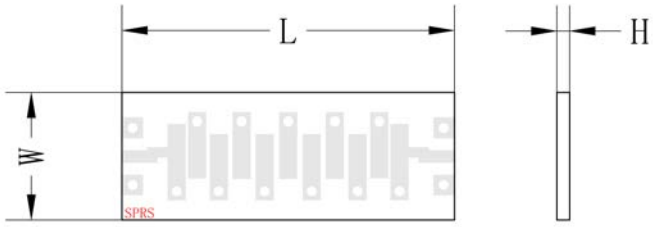
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	18.9	GHz
工作带宽	13.7-24.1	GHz
中心损耗	1.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-10.0GHz	dBc
带外抑制	40@28.9-41.0GHz	dBc

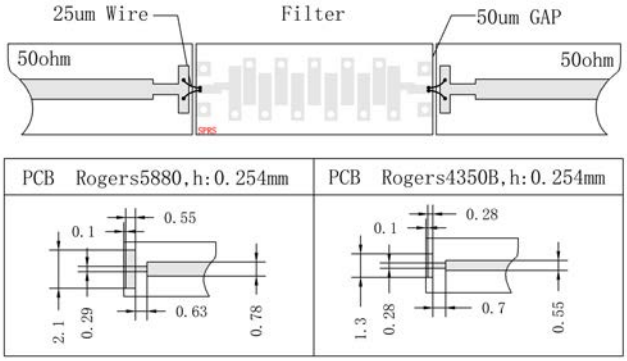
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



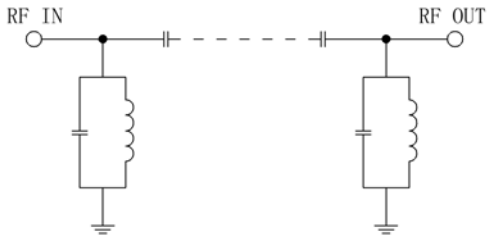
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.87mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

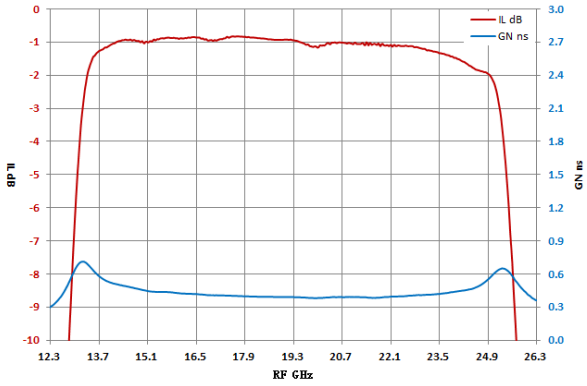
参考实物图

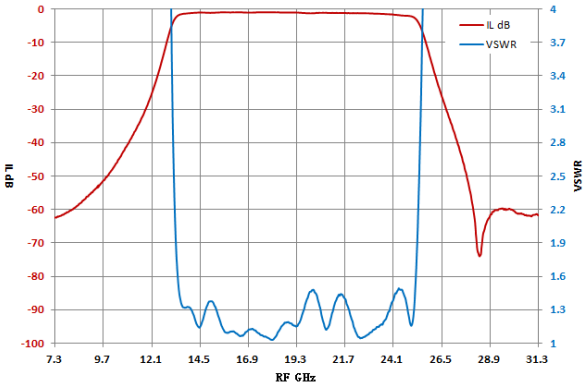


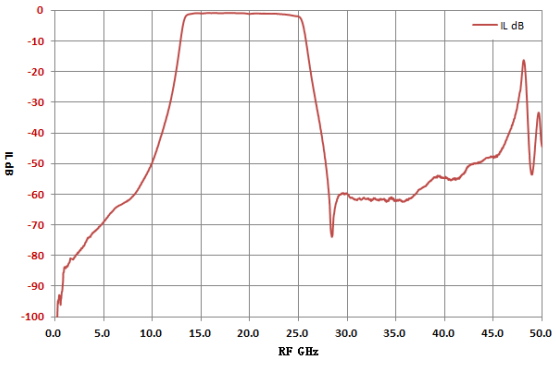
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

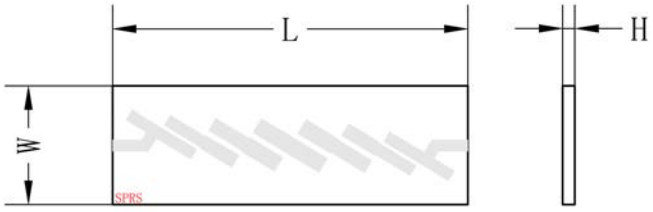
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	13.9	GHz
工作带宽	13.8-14.0	GHz
中心损耗	6.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	1.0	ns
带外抑制	40@DC-13.2GHz	dBc
带外抑制	40@14.5-25.0GHz	dBc

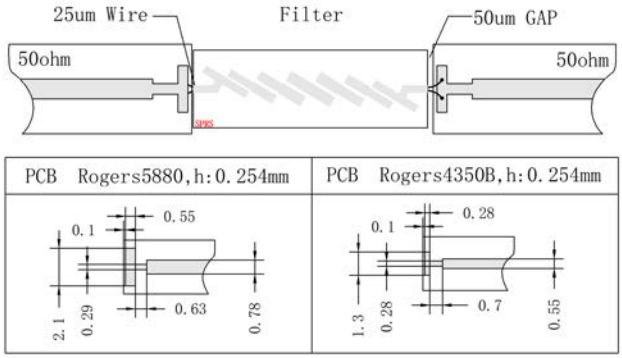
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



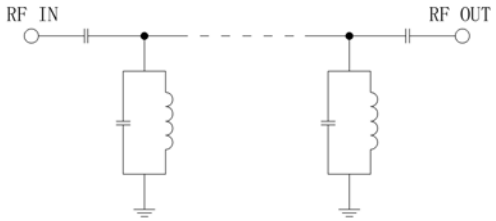
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

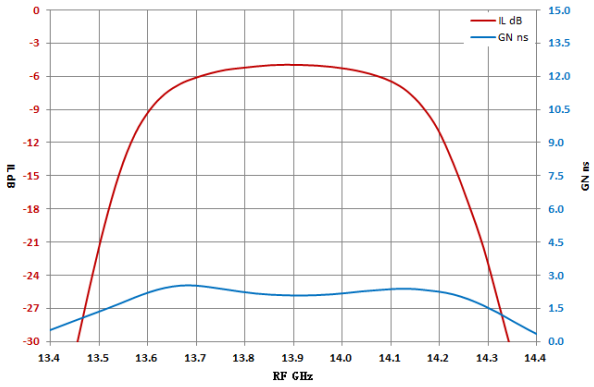
参考实物图

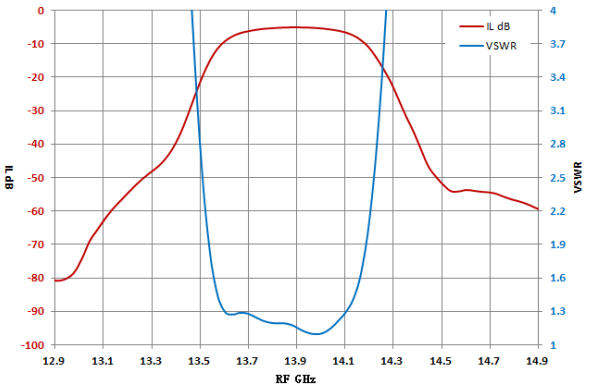


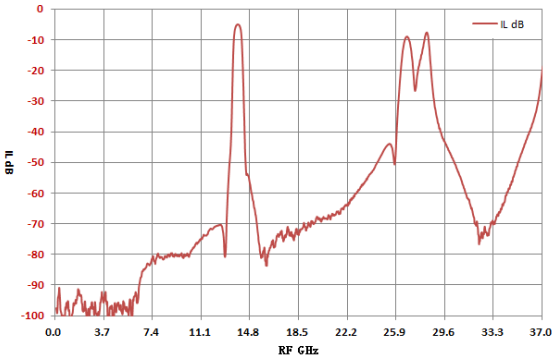
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

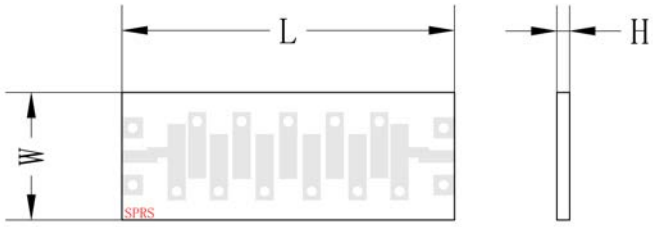
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	13.9	GHz
工作带宽	13.8-14.0	GHz
中心损耗	4.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	1.0	ns
带外抑制	40@DC-13.3GHz	dBc
带外抑制	40@14.5-30.4GHz	dBc

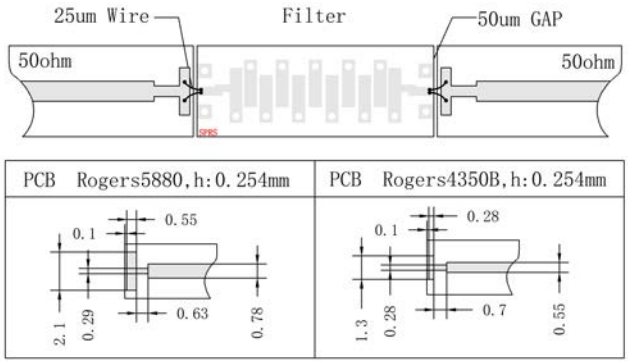
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



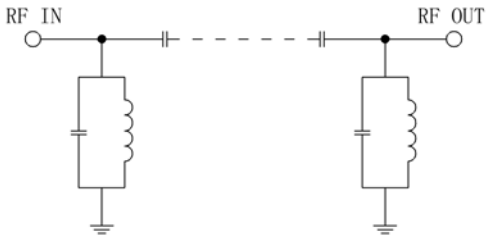
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

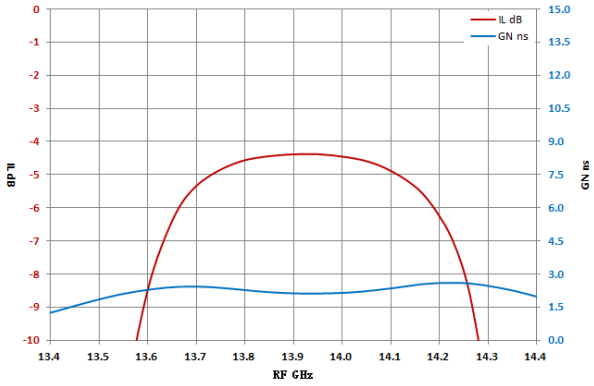
参考实物图

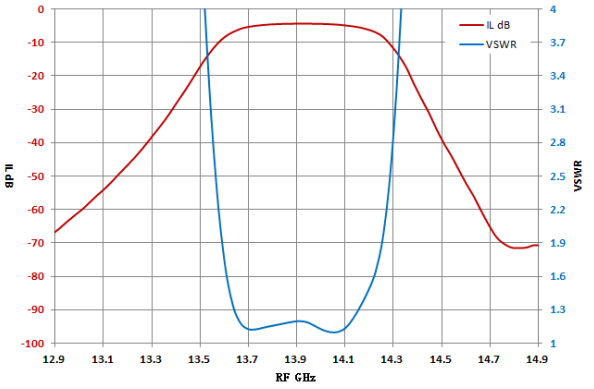


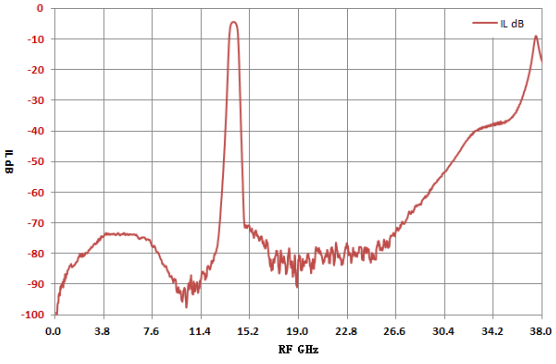
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



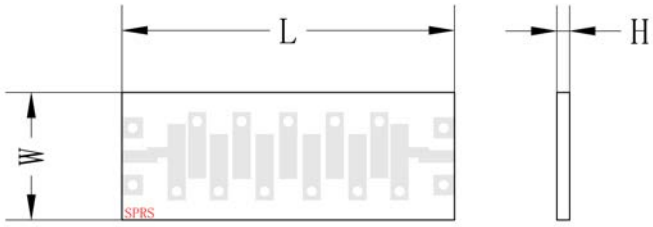
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	14.1	GHz
工作带宽	13.8-14.4	GHz
中心损耗	4.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.6	ns
带外抑制	40@DC-12.8GHz	dBc
带外抑制	40@15.4-35.0GHz	dBc

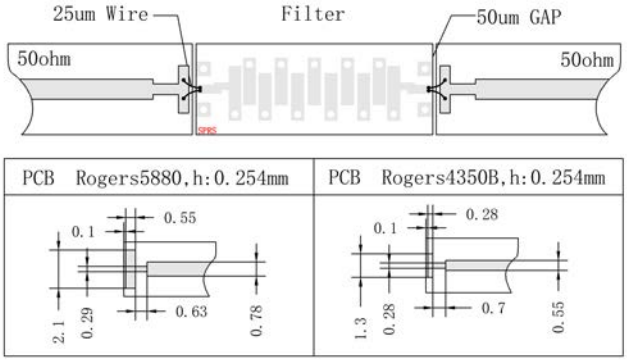
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



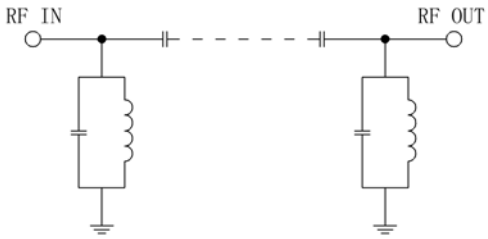
推荐装配图



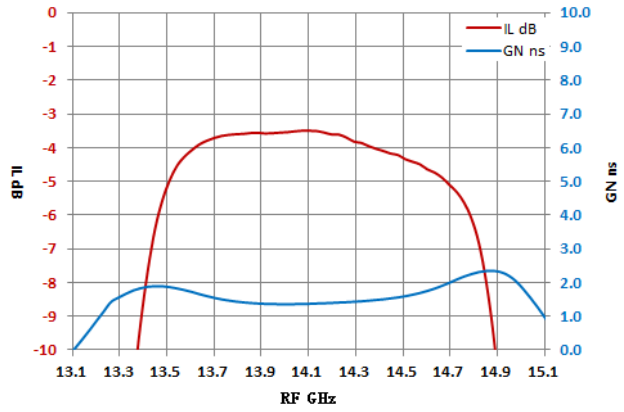
注意事项

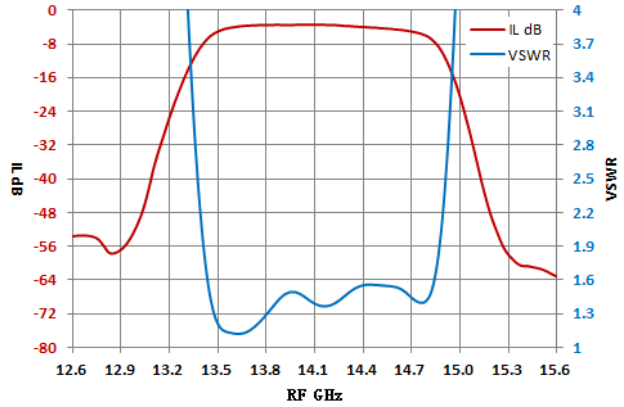
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

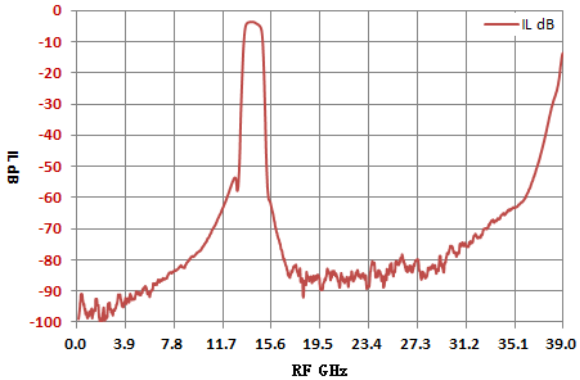
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



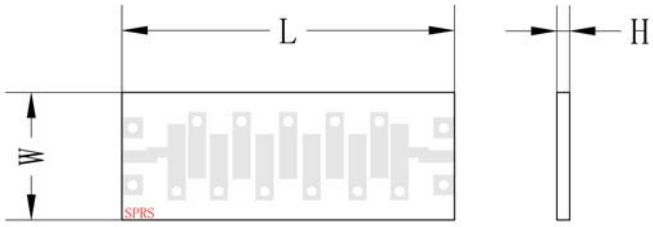
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	14.5	GHz
工作带宽	13.8-15.1	GHz
中心损耗	2.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-12.7GHz	dBc
带外抑制	40@16.2-34.0GHz	dBc

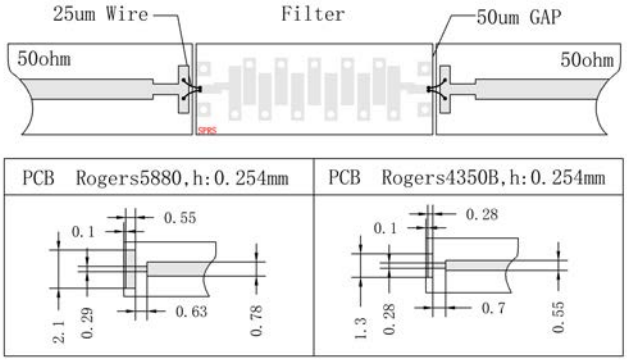
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



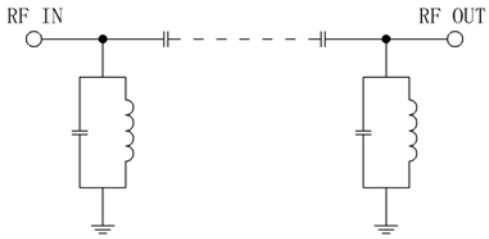
推荐装配图



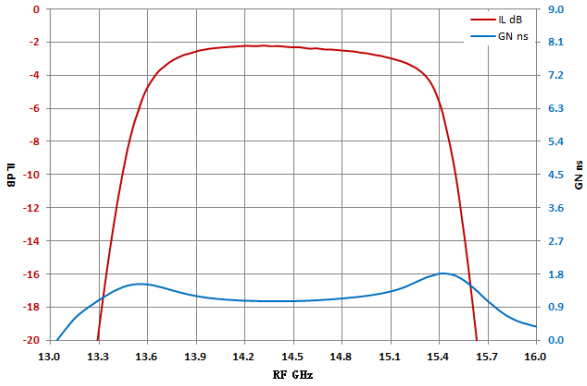
注意事项

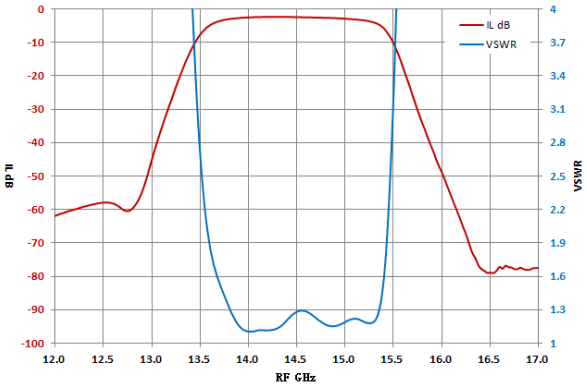
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

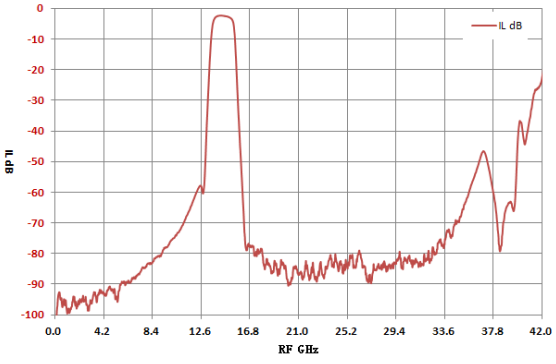
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



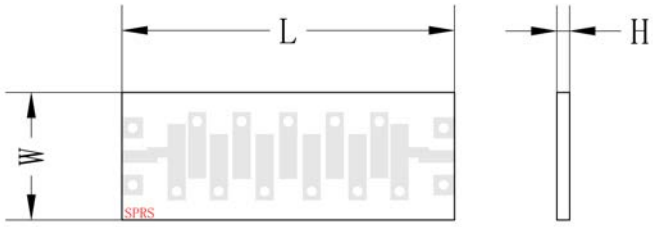
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	14.8	GHz
工作带宽	13.8-15.8	GHz
中心损耗	3.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-12.7GHz	dBc
带外抑制	40@17.0-37.0GHz	dBc

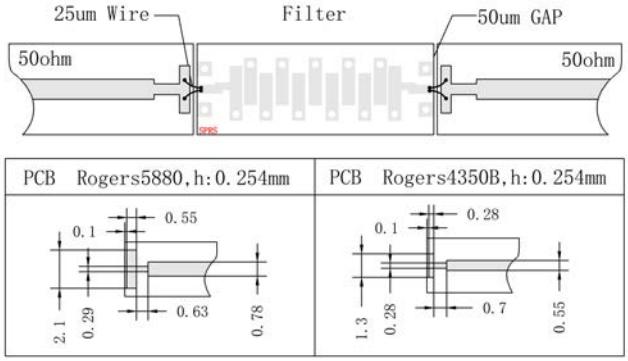
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：10.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



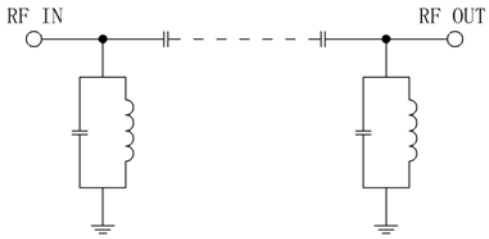
推荐装配图



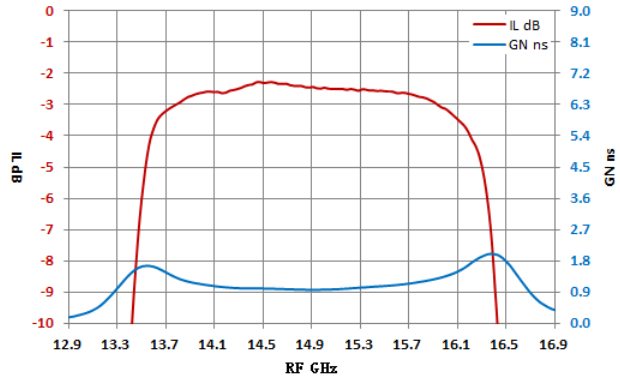
注意事项

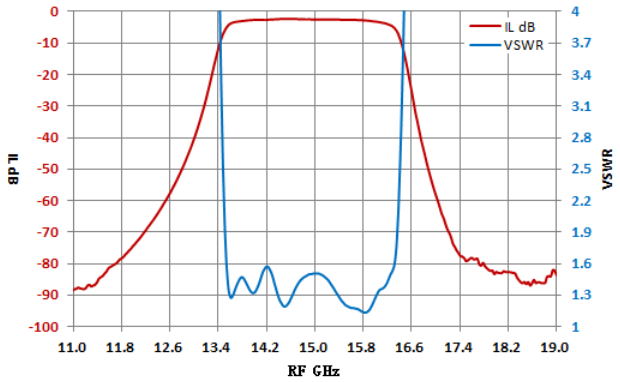
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

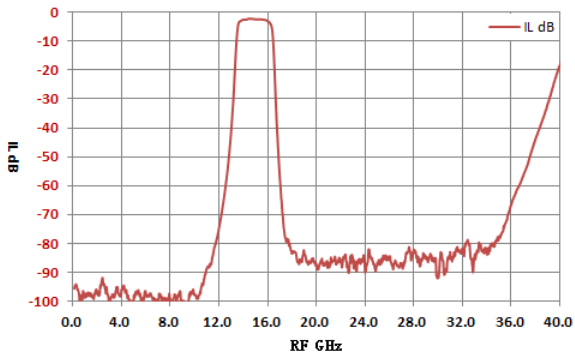
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



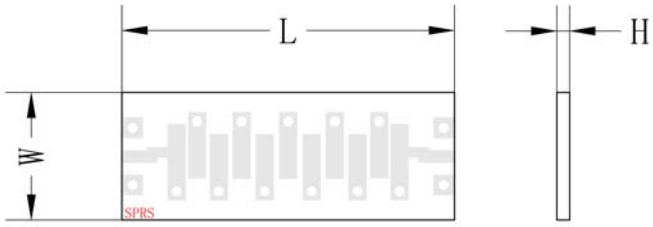
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	15.0	GHz
工作带宽	13.8-16.2	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-12.6GHz	dBc
带外抑制	40@17.7-34.0GHz	dBc

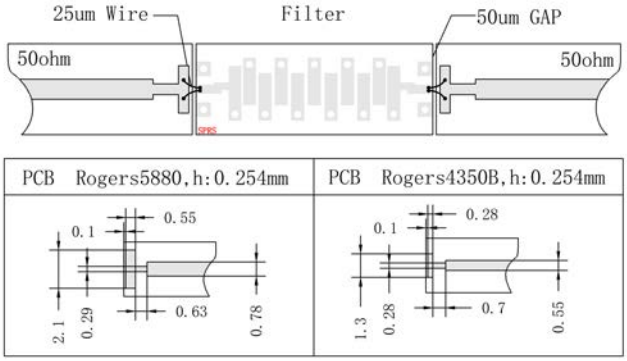
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



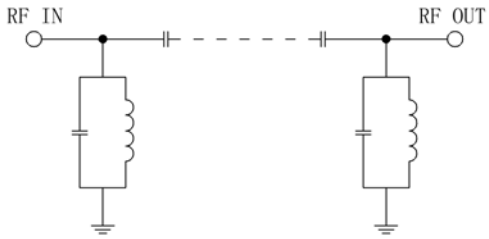
推荐装配图



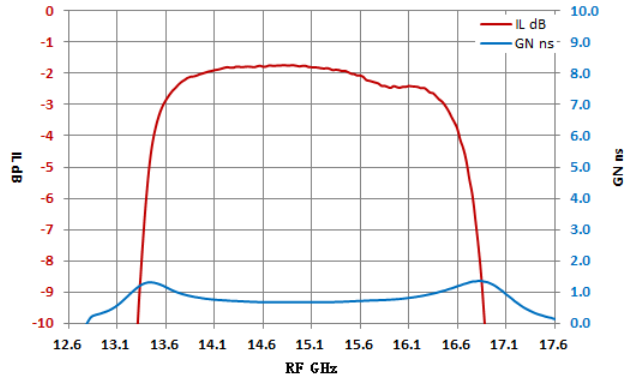
注意事项

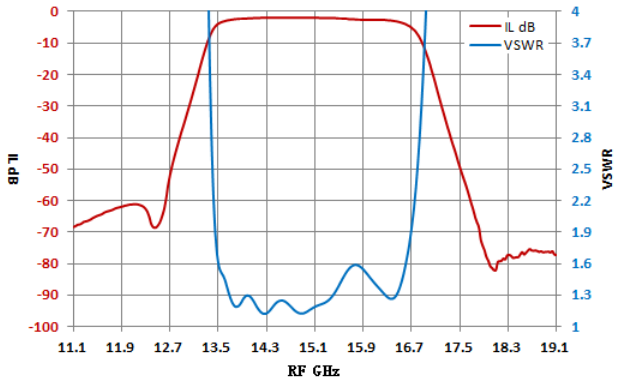
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

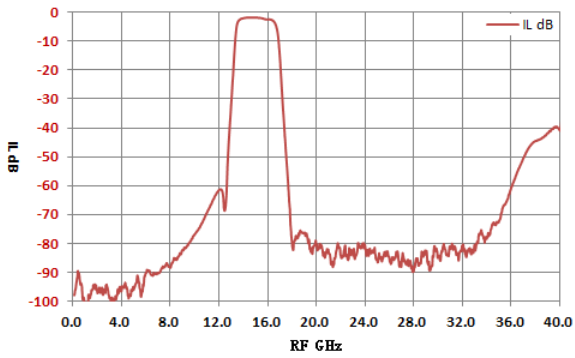
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

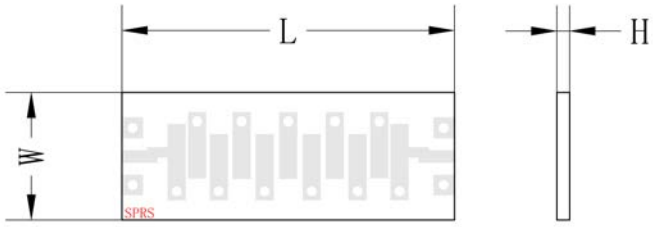
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	15.6	GHz
工作带宽	13.8-17.4	GHz
中心损耗	0.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-8.2GHz	dBc
带外抑制	40@21.2-35.0GHz	dBc

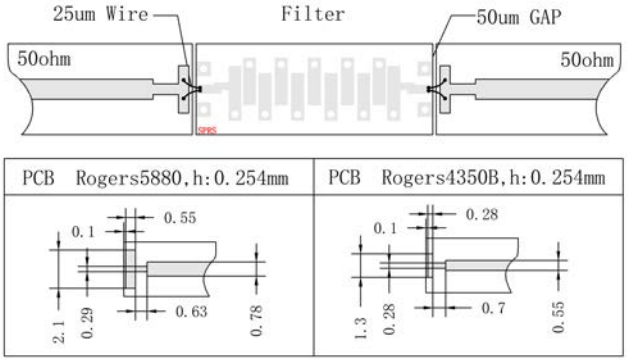
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：5.5，W：2.7，h：0.39

外形图：端口居中



推荐装配图



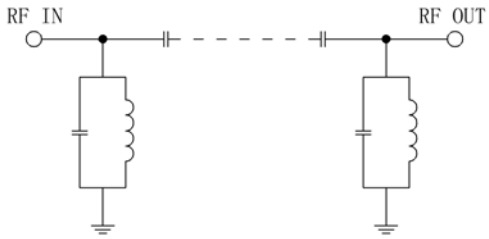
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.61mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

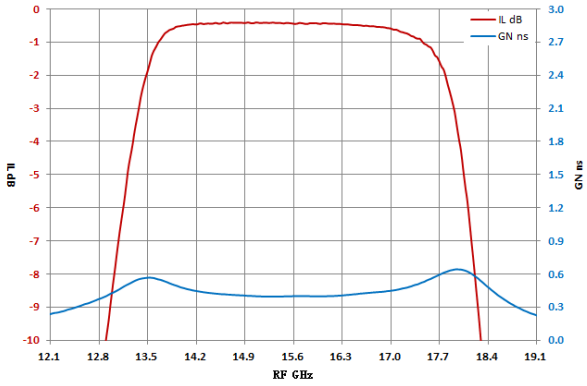
参考实物图

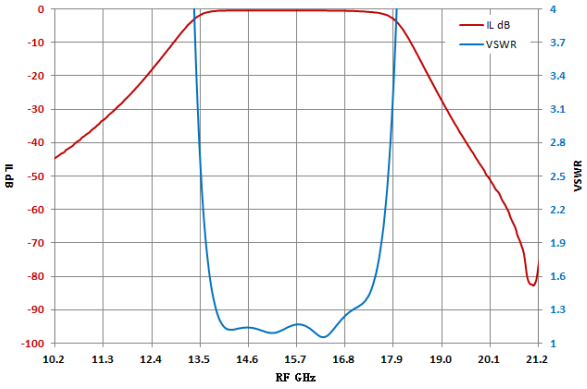


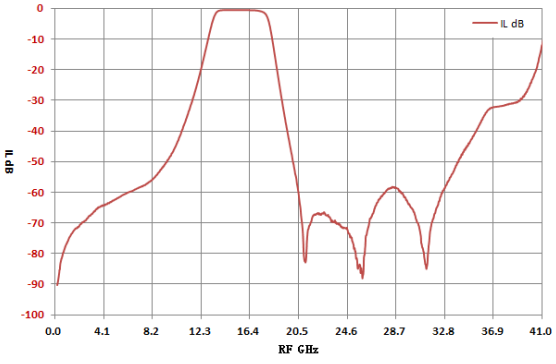
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

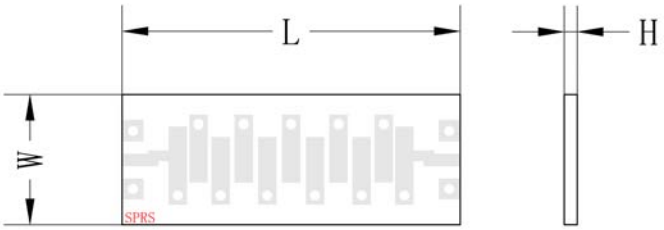
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	16.8	GHz
工作带宽	13.8-19.8	GHz
中心损耗	1.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	50@DC-10.2GHz	dBc
带外抑制	35@21.4-43.0GHz	dBc

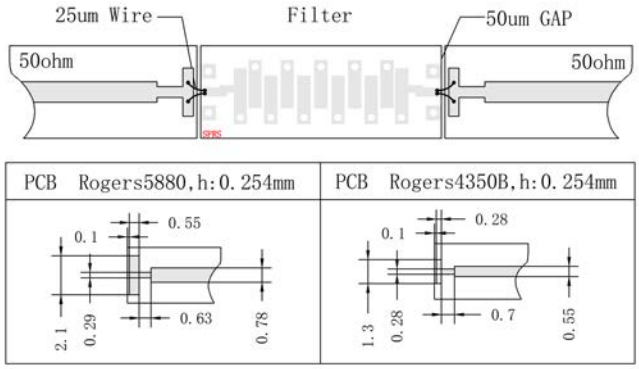
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

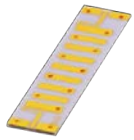
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

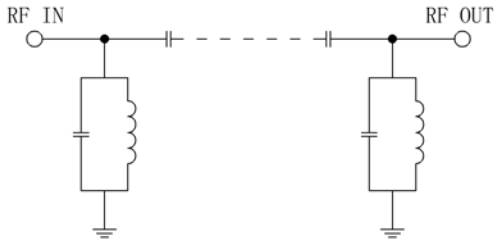
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

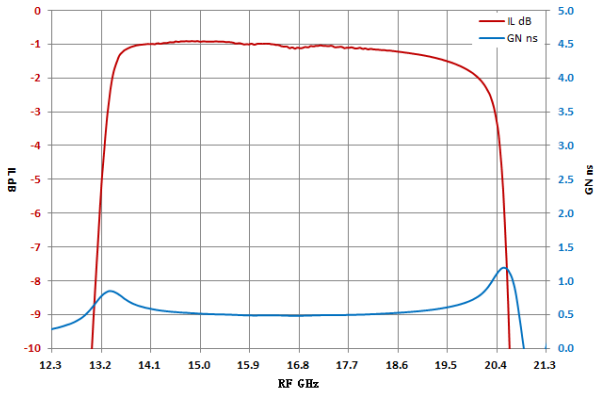
参考图

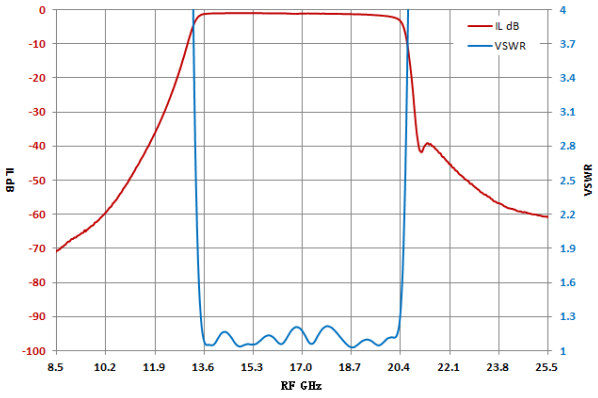


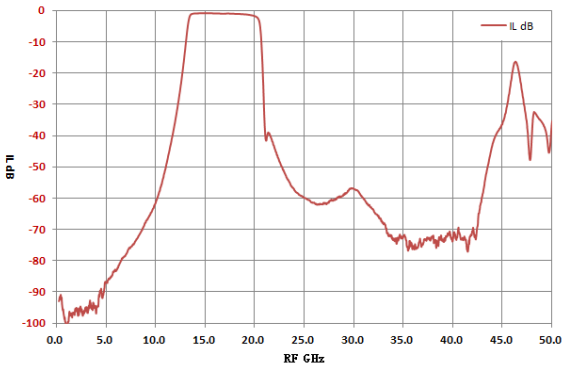
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

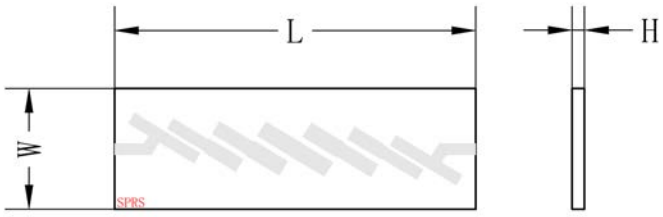
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	13.9	GHz
中心损耗	6.4	dB
驻波比	1.7:1	
带外抑制	40@DC-13.0GHz	dBc
带外抑制	40@14.6-23.0GHz	dBc

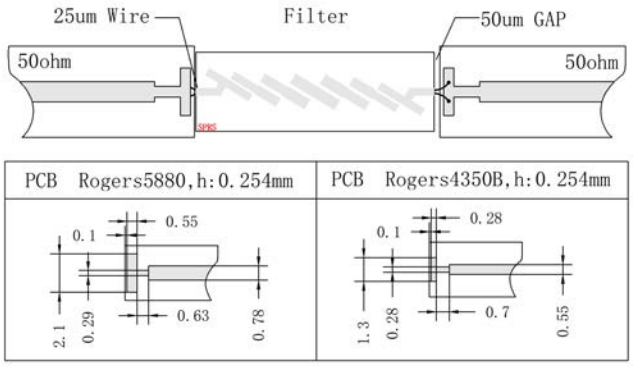
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：8.0，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

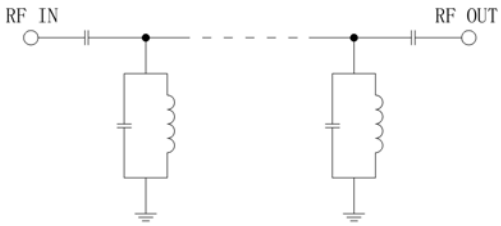
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

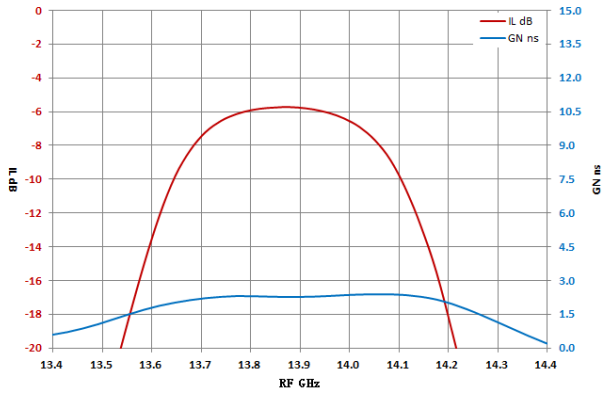
参考图

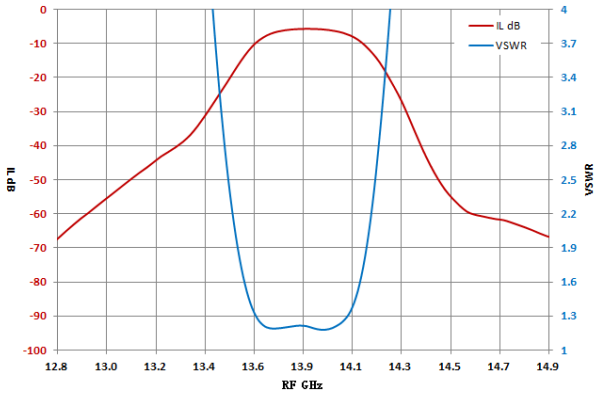


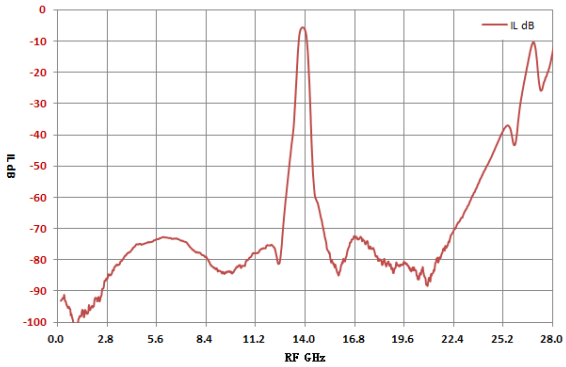
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

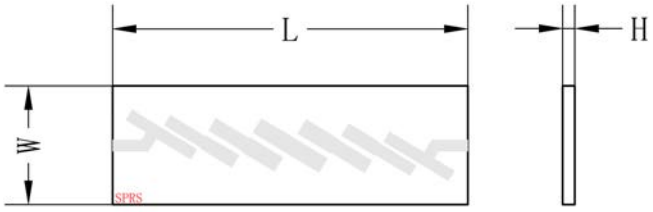
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	14.0	GHz
工作带宽	13.9-14.1	GHz
中心损耗	5.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	1.0	ns
带外抑制	40@DC-13.2GHz	dBc
带外抑制	40@14.2-26.0GHz	dBc

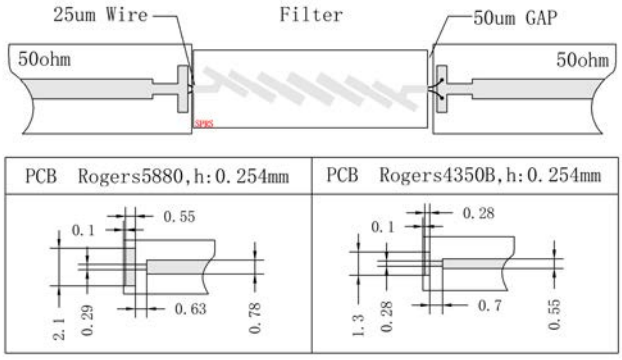
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



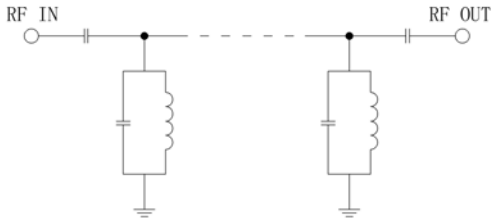
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

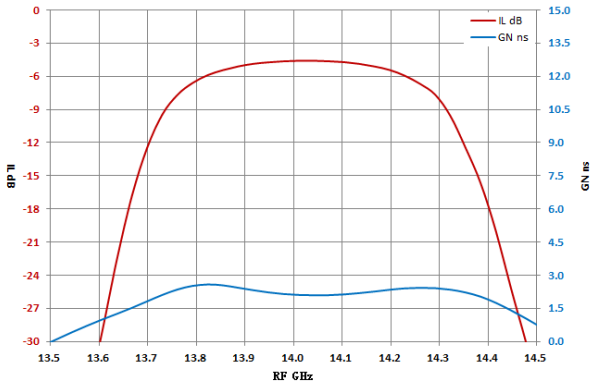
参考实物图

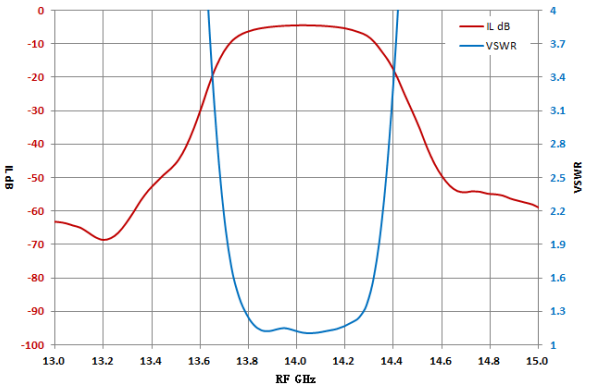


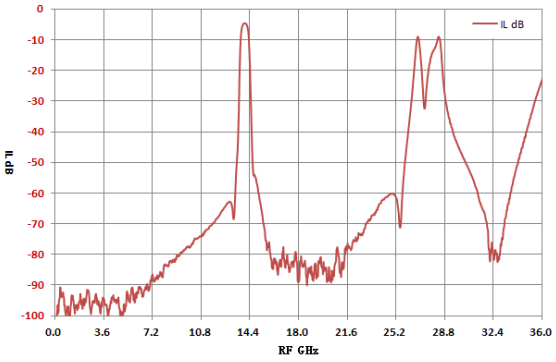
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

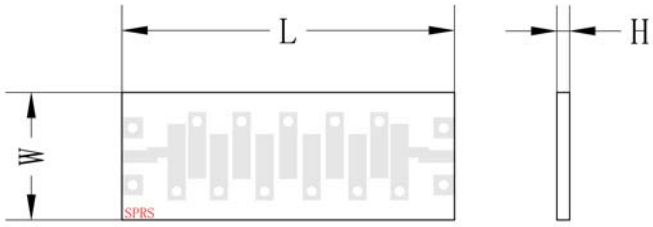
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	14	GHz
工作带宽	13.95-14.05	GHz
中心损耗	5.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-12.5GHz	dBc
带外抑制	40@14.8-35.0GHz	dBc

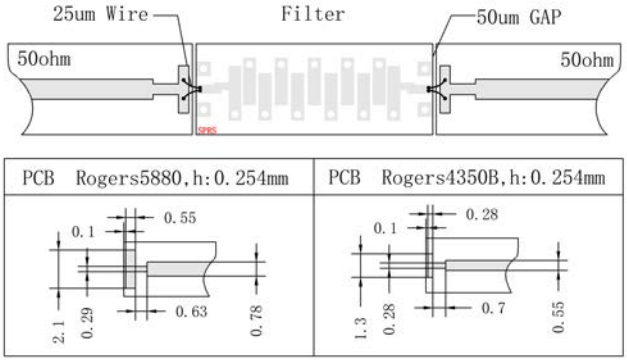
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



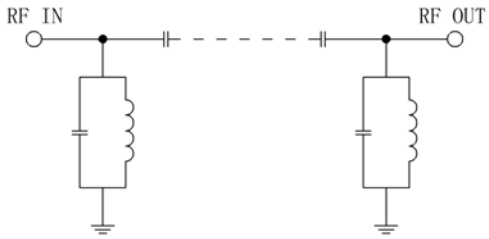
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

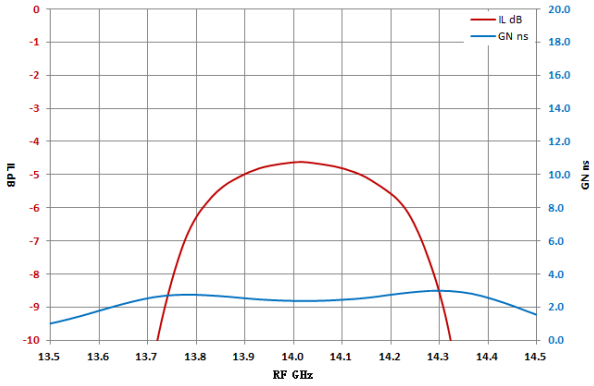
参考实物图

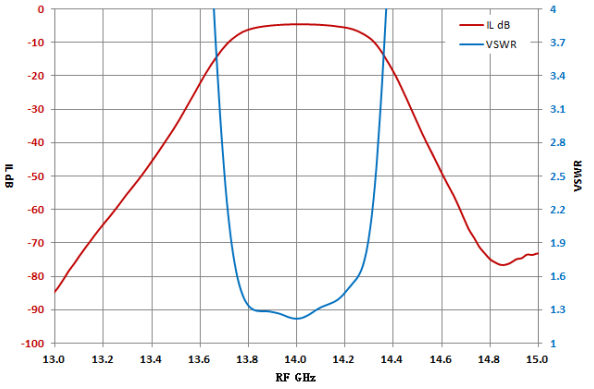


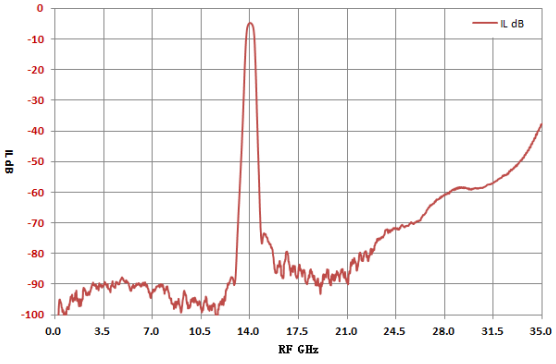
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



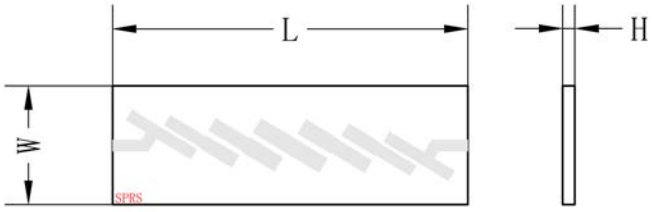
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	14.0	GHz
工作带宽	0	GHz
中心损耗	7.0	dB
带内波动	0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0	ns
带外抑制	40@DC-13.4GHz	dBc
带外抑制	40@14.7-23.0GHz	dBc

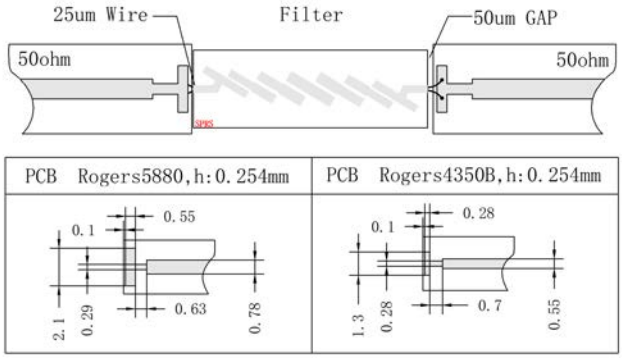
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



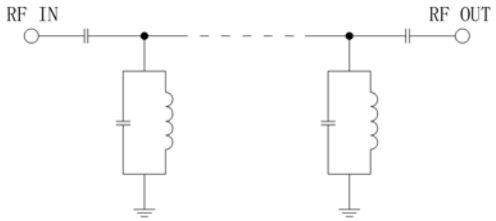
推荐装配图



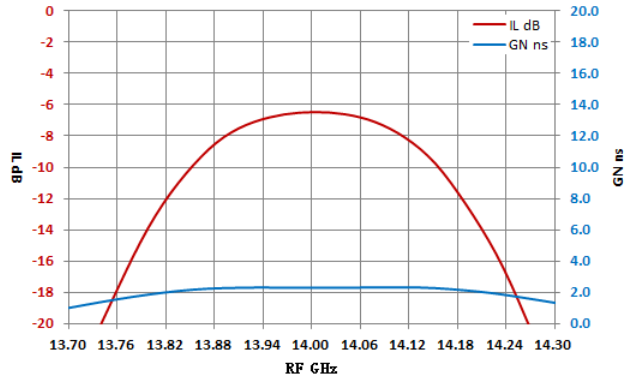
注意事项

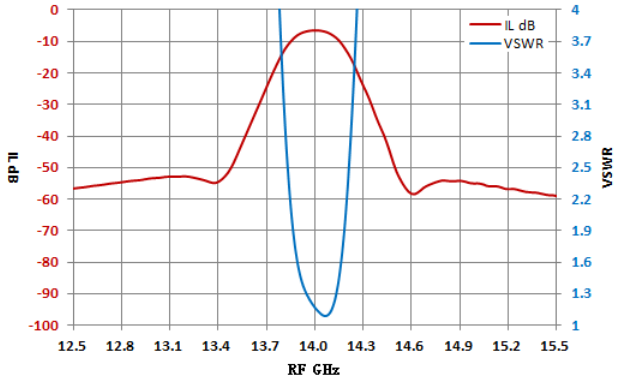
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

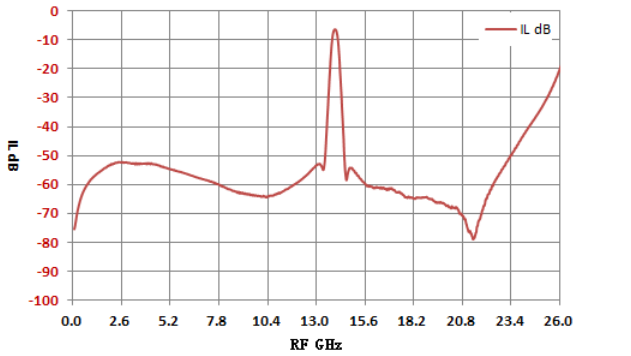
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

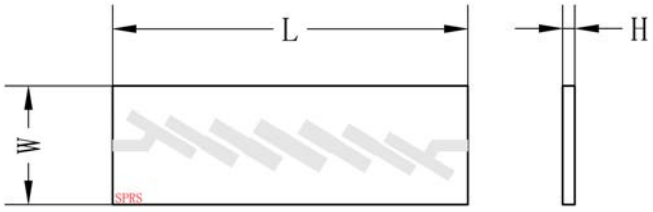
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	14.65	GHz
工作带宽	14.0-15.3	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-12.9GHz	dBc
带外抑制	40@16.3-27.4GHz	dBc

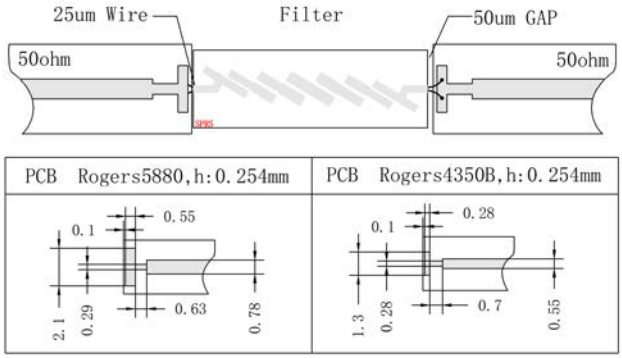
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



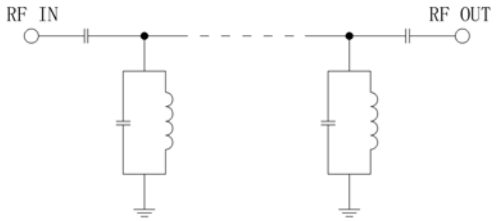
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

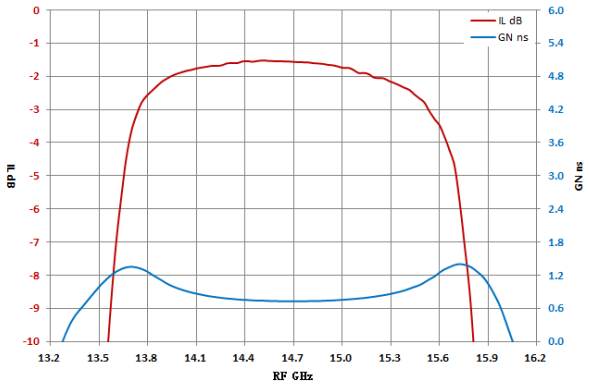
参考实物图

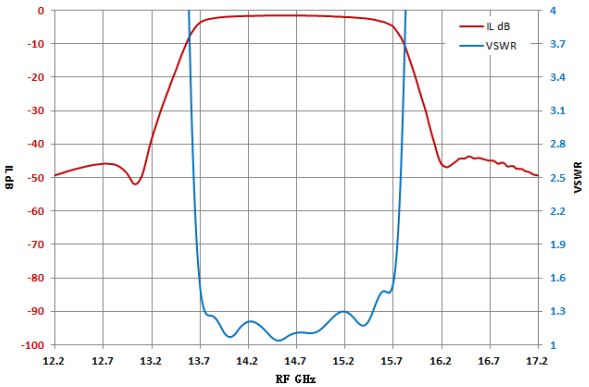


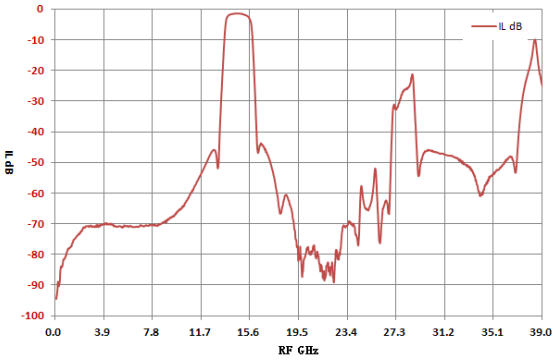
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

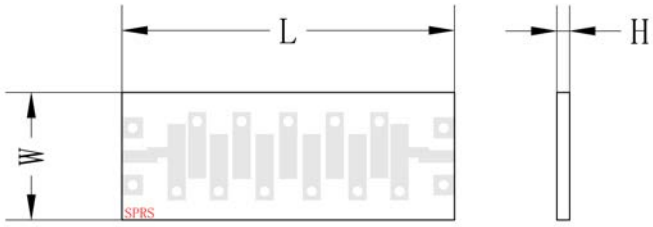
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	16.7	GHz
工作带宽	14.0-19.4	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-11.6GHz	dBc
带外抑制	40@23.1-38.0GHz	dBc

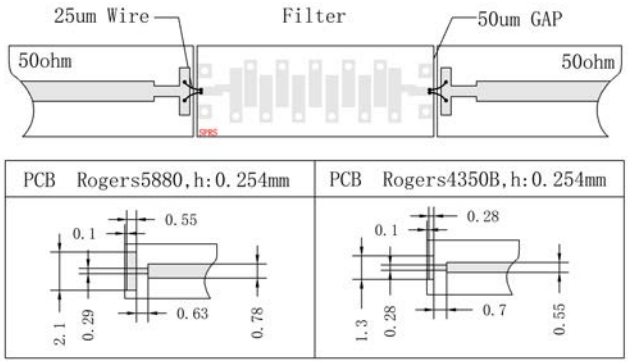
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：2.7，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



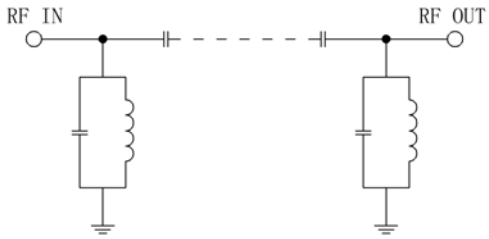
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.87mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

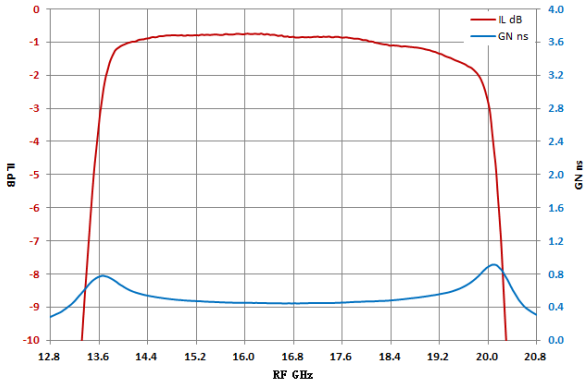
参考实物图

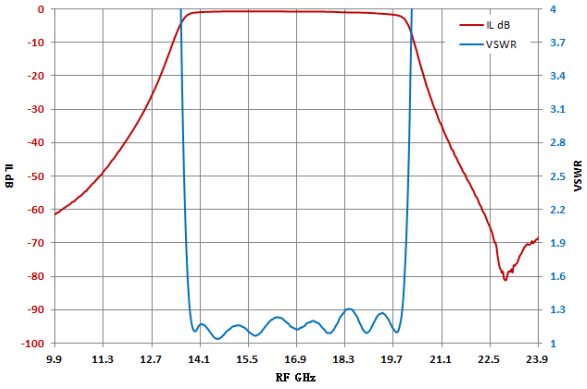


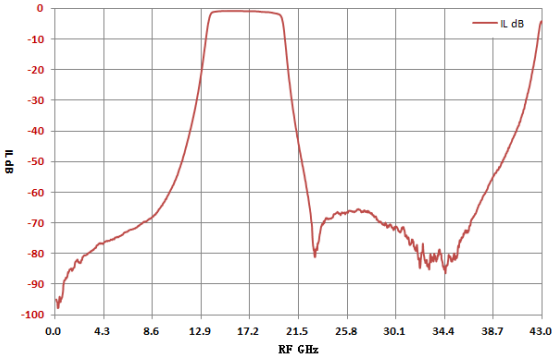
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

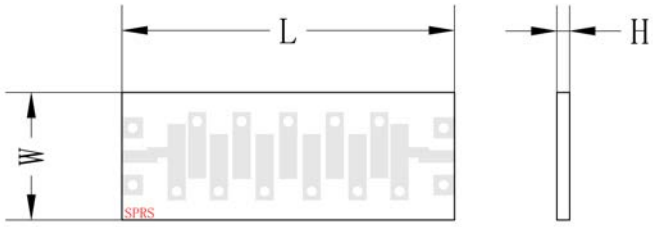
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	14.95	GHz
工作带宽	14.1-15.8	GHz
中心损耗	2.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-12.9GHz	dBc
带外抑制	40@17.0-35.0GHz	dBc

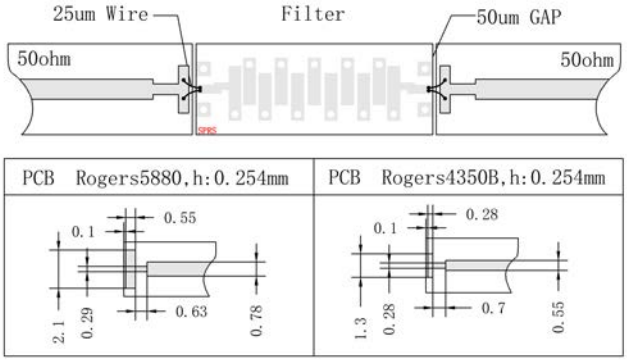
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



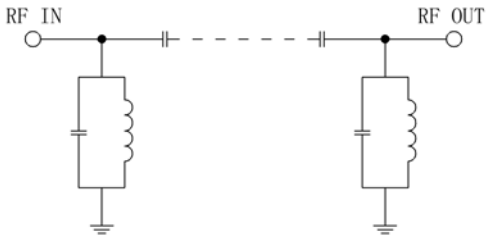
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

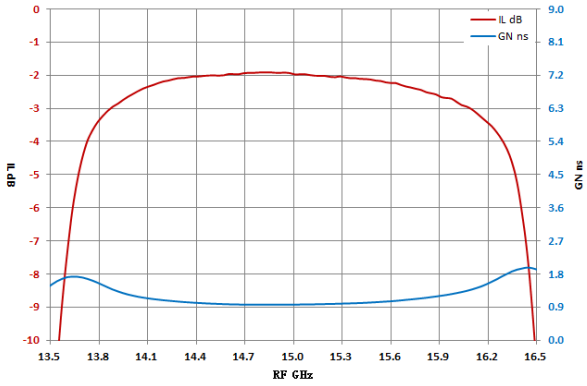
参考实物图

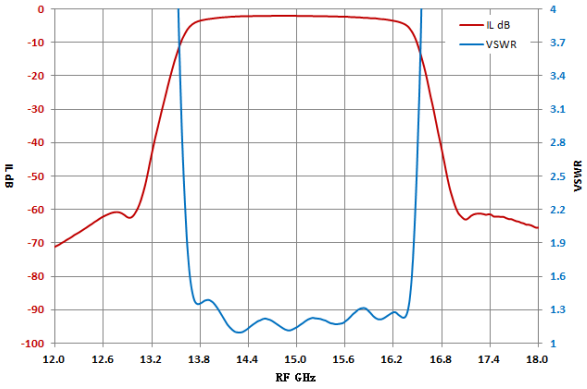


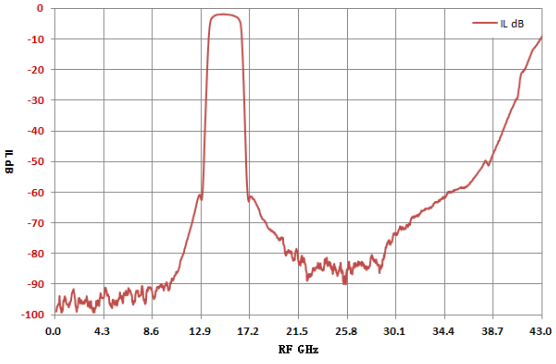
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



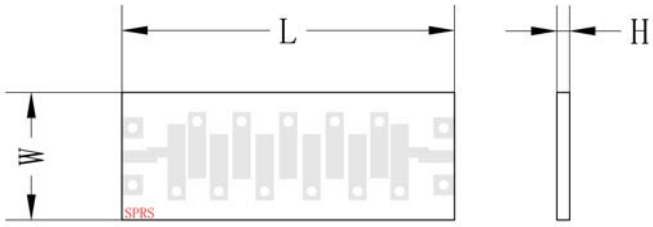
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	16.2	GHz
工作带宽	14.1-18.3	GHz
中心损耗	1.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-10.8GHz	dBc
带外抑制	40@21.0-37.0GHz	dBc

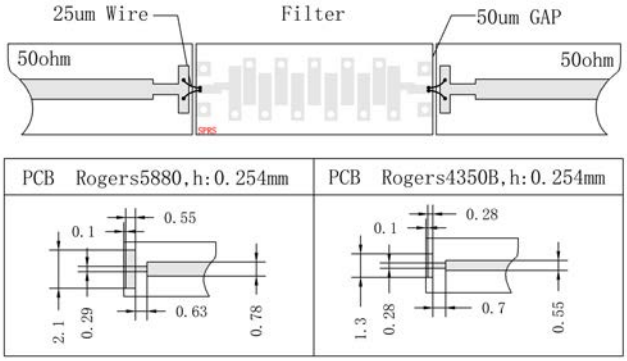
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：2.3，h：0.26

外形图：端口居中



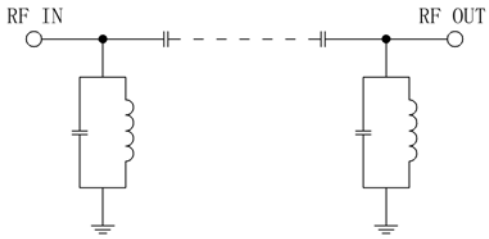
推荐装配图



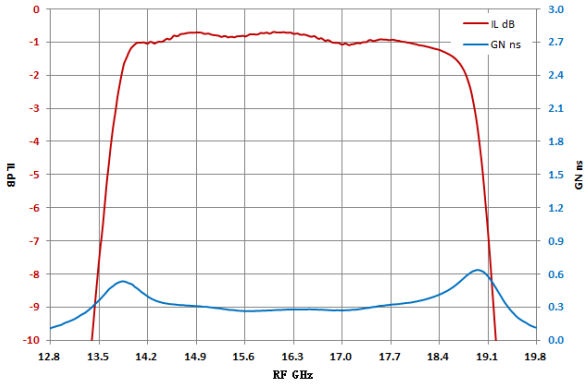
注意事项

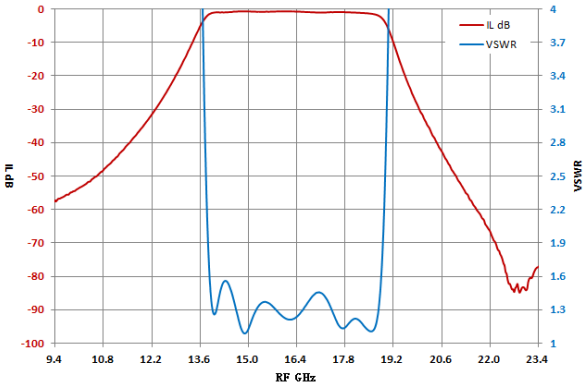
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

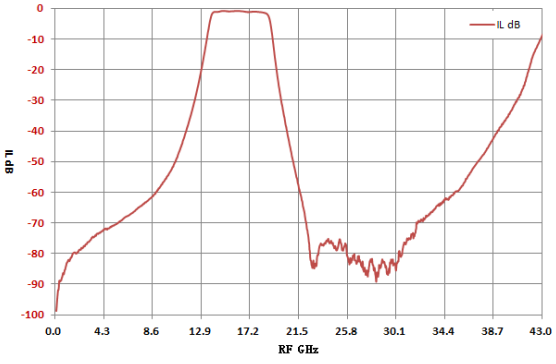
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

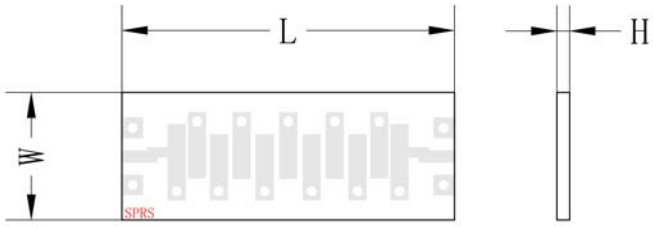
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	14.7	GHz
工作带宽	14.2-15.2	GHz
中心损耗	3.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-12.7GHz	dBc
带外抑制	40@16.7-36.0GHz	dBc

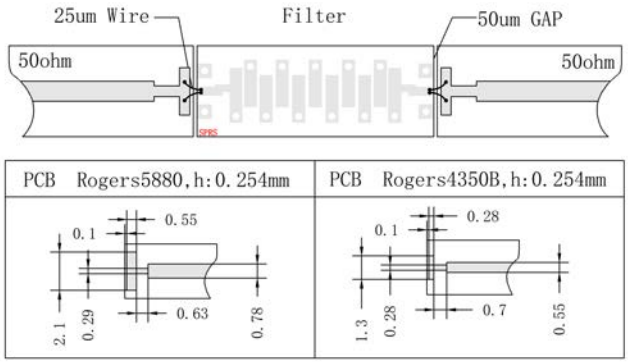
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



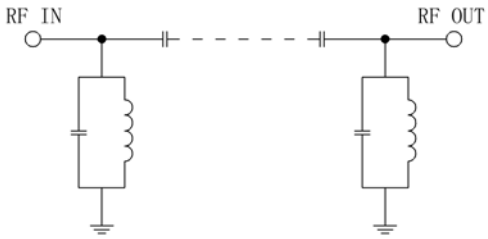
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

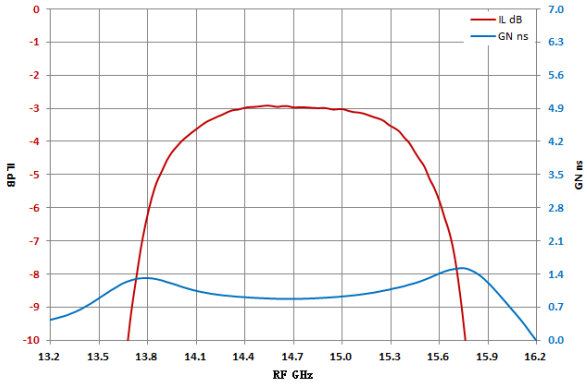
参考实物图

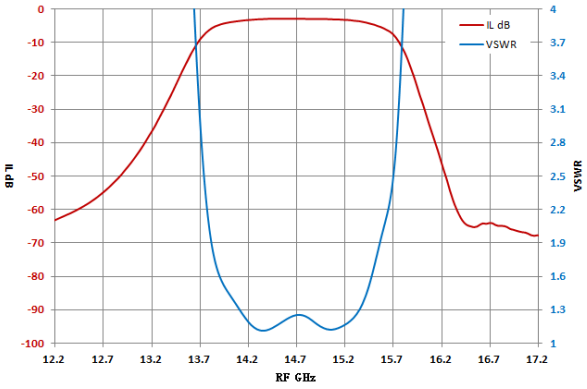


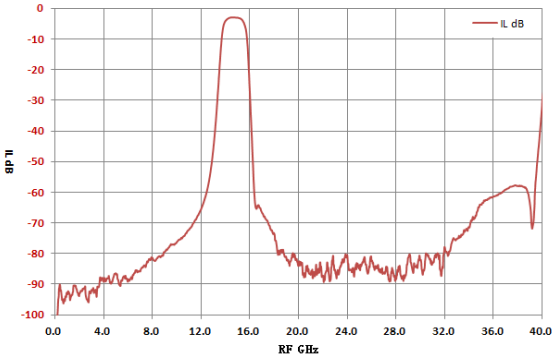
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



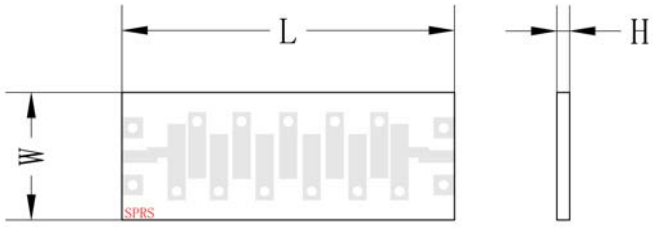
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	15.7	GHz
工作带宽	14.2-17.2	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-12.5GHz	dBc
带外抑制	40@18.6-38.0GHz	dBc

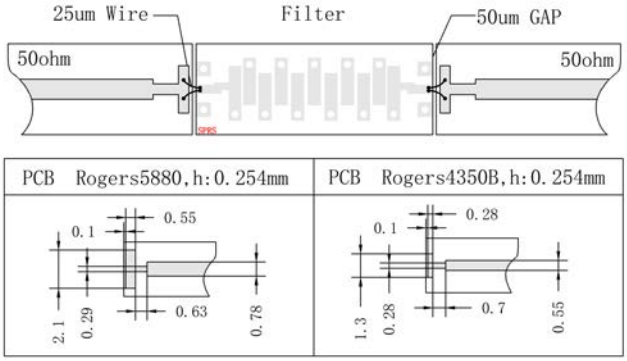
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



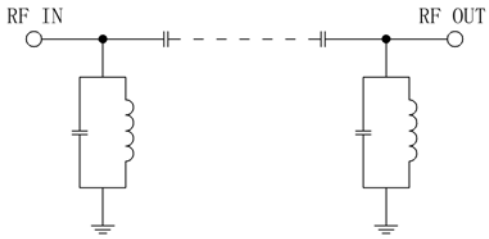
推荐装配图



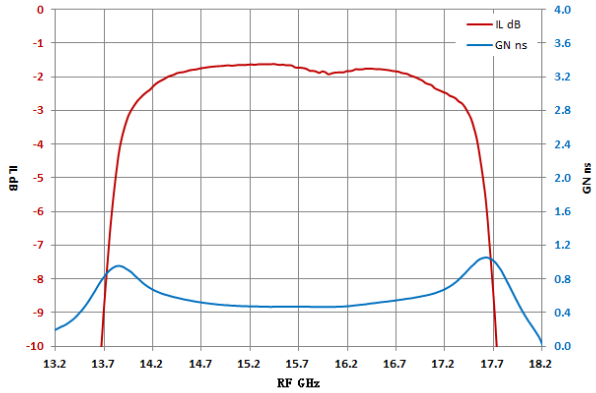
注意事项

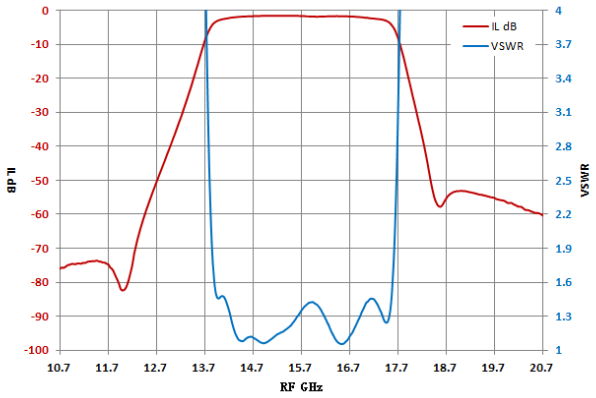
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

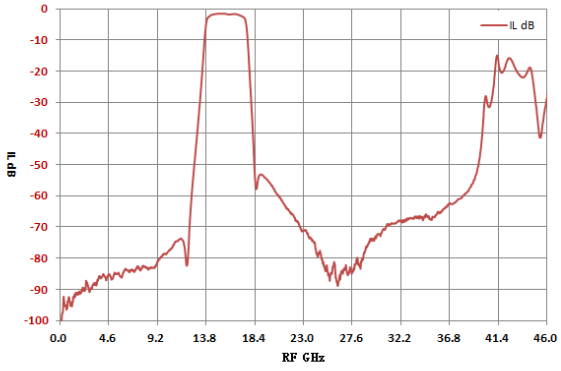
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



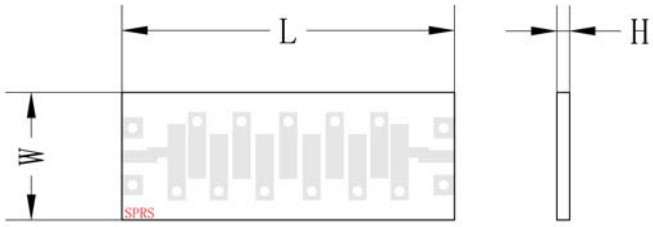
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	16.1	GHz
工作带宽	14.2-17.9	GHz
中心损耗	2.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-12.8GHz	dBc
带外抑制	40@19.4-37.0GHz	dBc

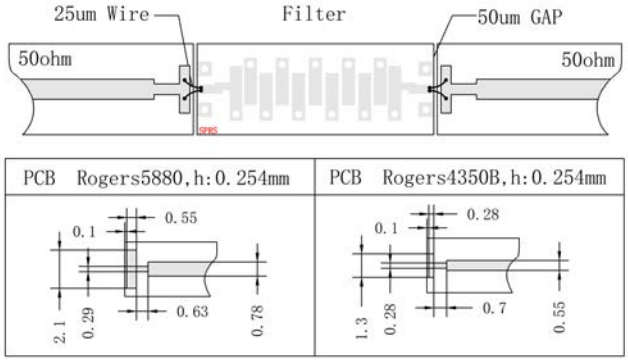
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



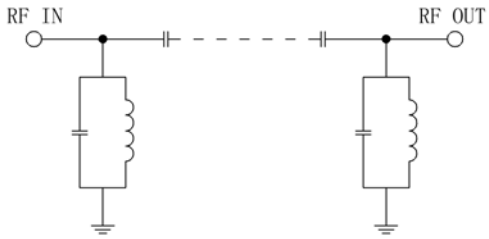
推荐装配图



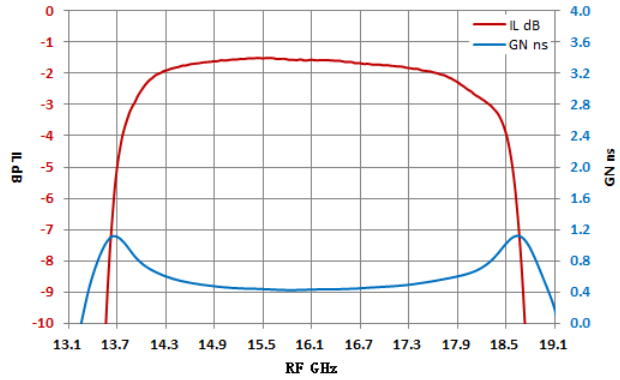
注意事项

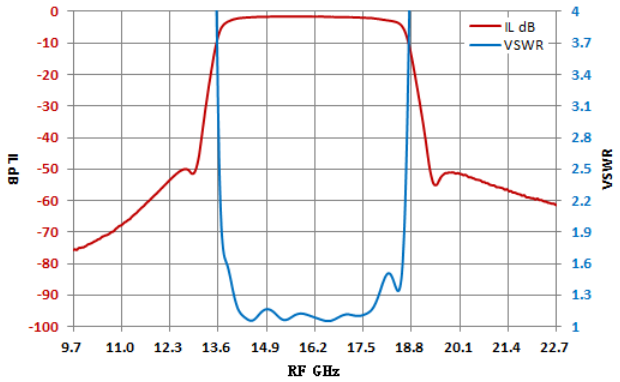
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

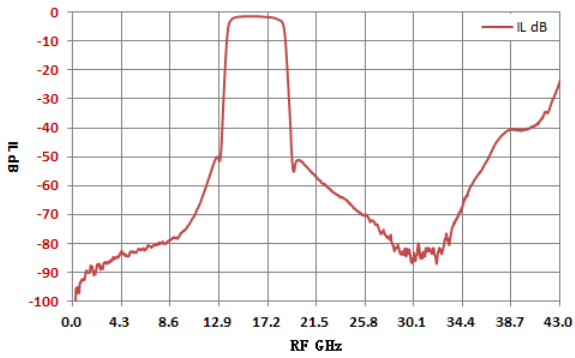
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

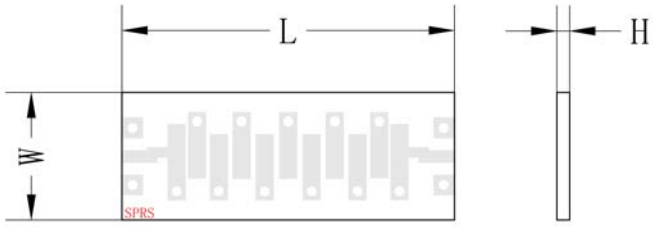
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	16.45	GHz
工作带宽	14.3-18.6	GHz
中心损耗	2.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-11.6GHz	dBc
带外抑制	40@21.1-36.0GHz	dBc

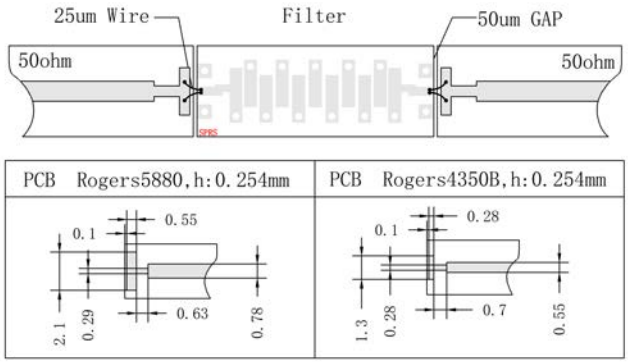
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：2.1，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



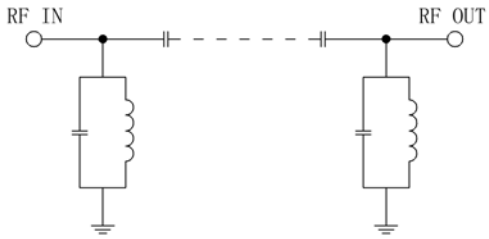
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.87mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

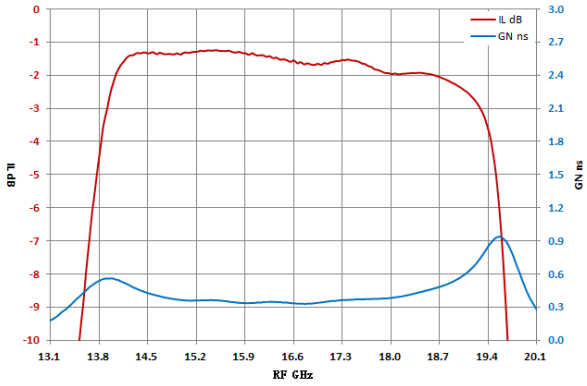
参考实物图

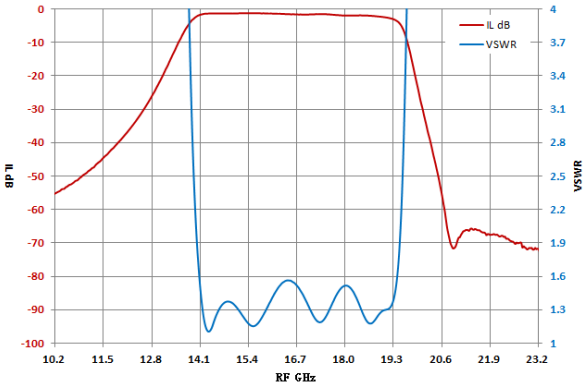


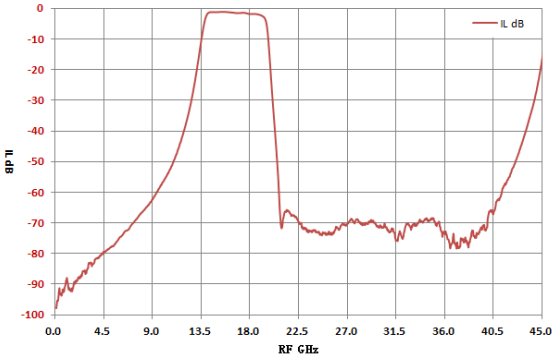
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

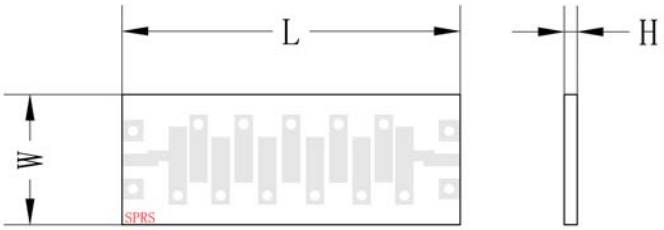
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	14.9	GHz
工作带宽	14.4-15.4	GHz
中心损耗	2.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-13.3GHz	dBc
带外抑制	40@16.5-36.0GHz	dBc

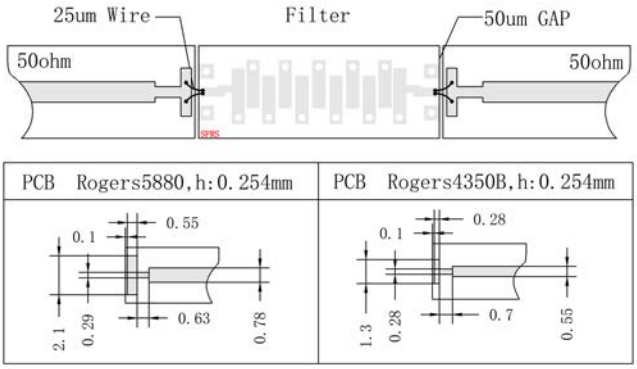
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：8.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

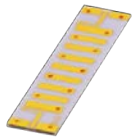
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

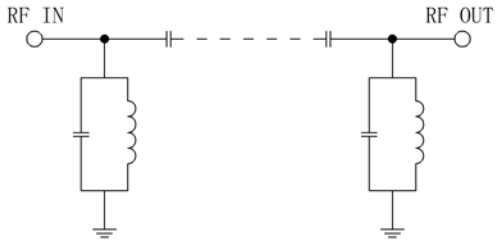
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

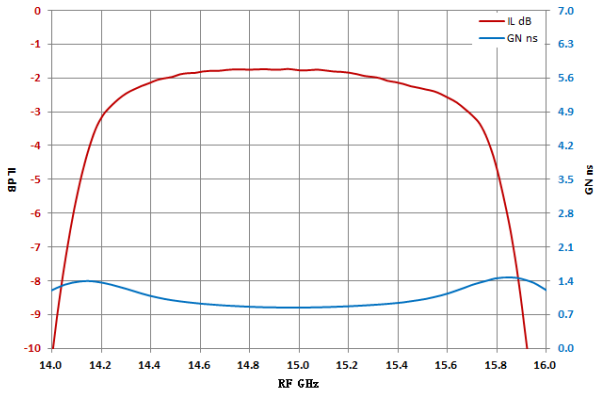
参考图

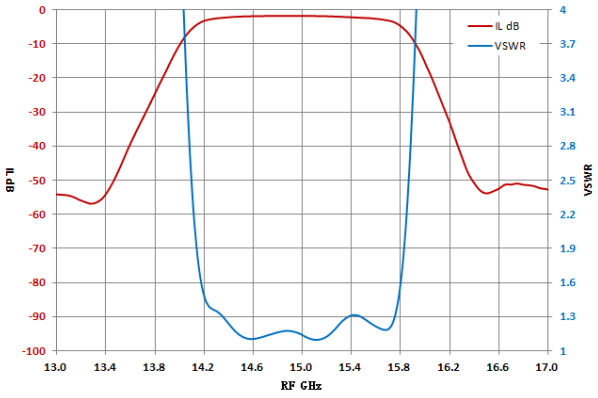


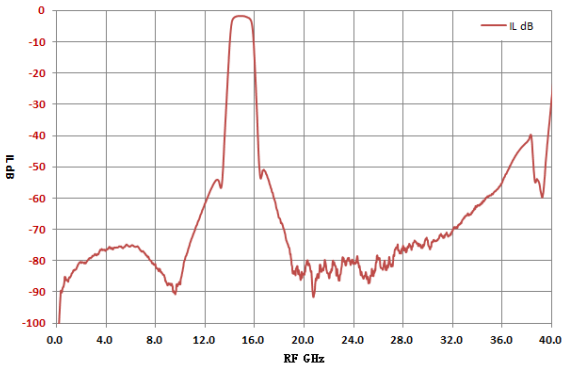
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



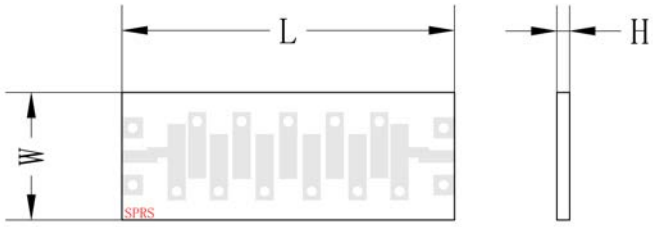
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	17.6	GHz
工作带宽	14.4-20.7	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-12.5GHz	dBc
带外抑制	40@23.0-41.0GHz	dBc

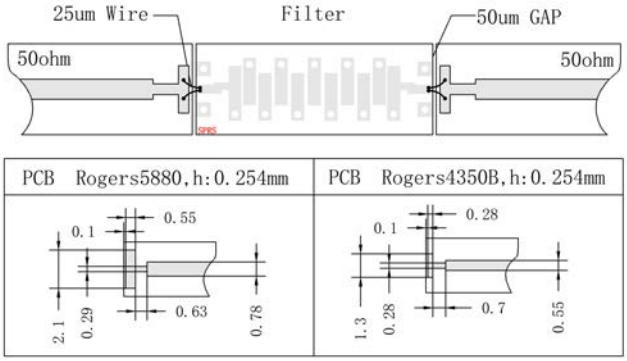
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



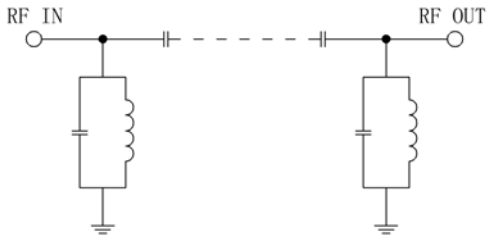
推荐装配图



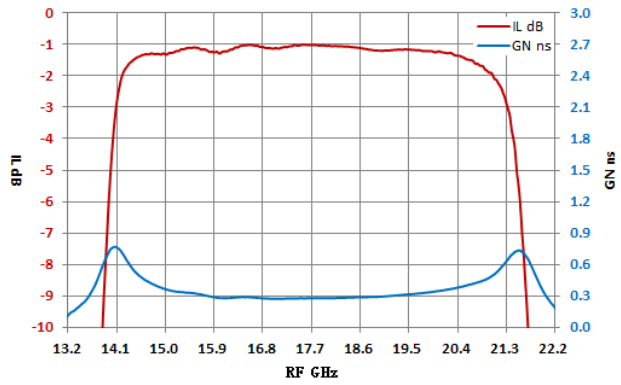
注意事项

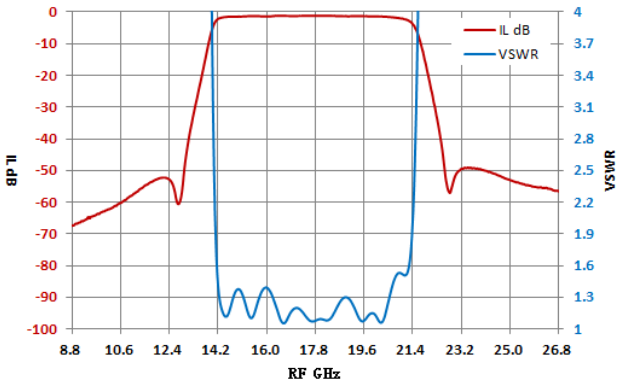
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

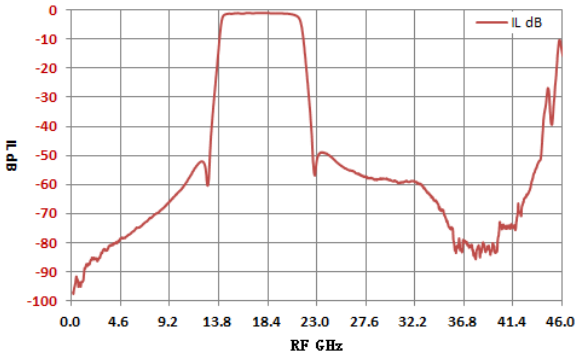
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



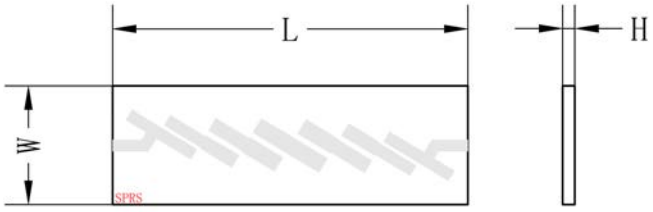
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	14.5	GHz
工作带宽	0	GHz
中心损耗	7.0	dB
带内波动	0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0	ns
带外抑制	40@DC-13.9GHz	dBc
带外抑制	40@15.1-23.0GHz	dBc

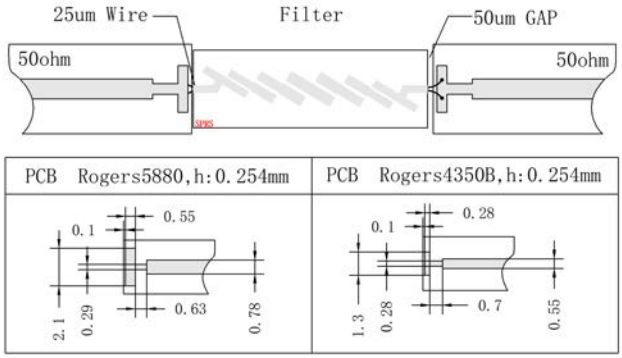
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



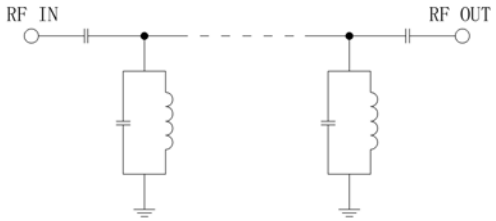
推荐装配图



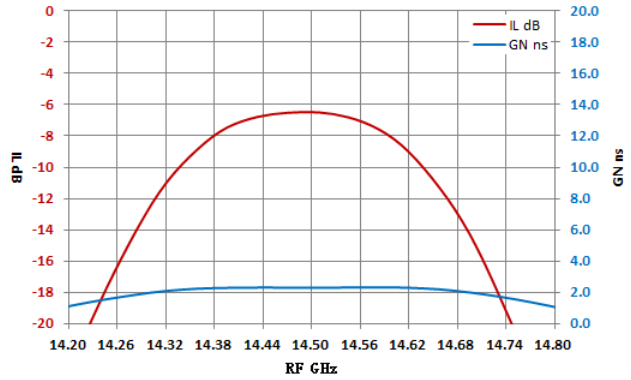
注意事项

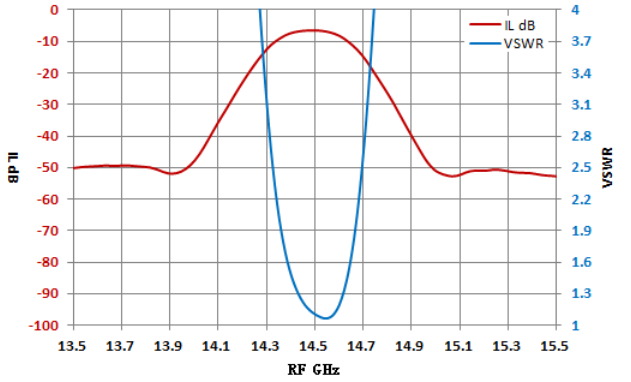
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

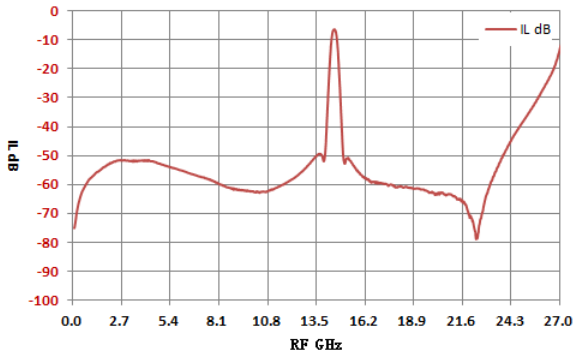
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

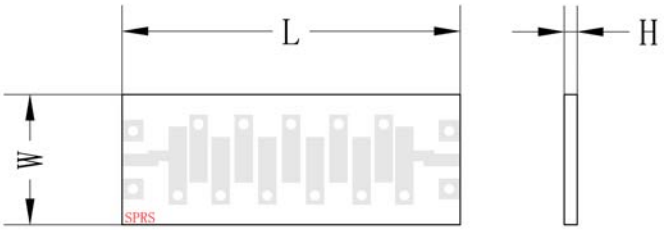
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	15.2	GHz
工作带宽	14.5-15.9	GHz
中心损耗	3.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.8:1	
群时延波动	0.6	ns
带外抑制	50@DC-13.4GHz	dBc
带外抑制	60@17.3-39.0GHz	dBc

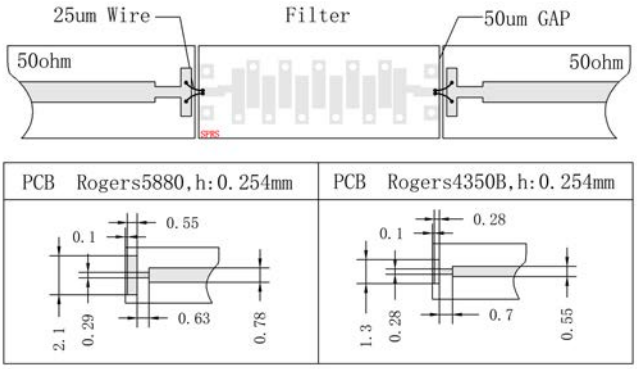
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：9.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

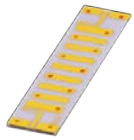
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

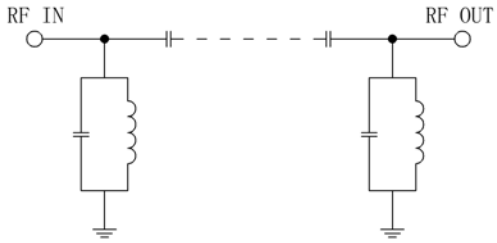
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

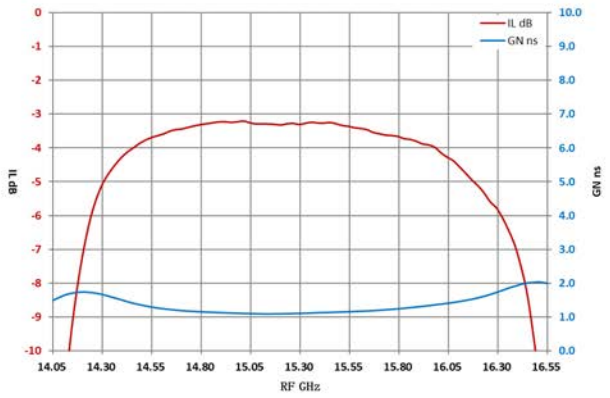
参考图

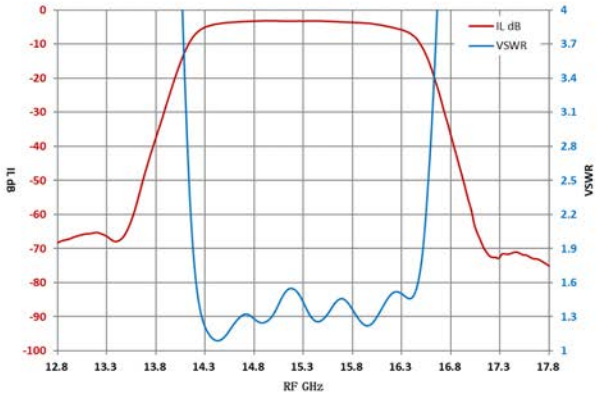


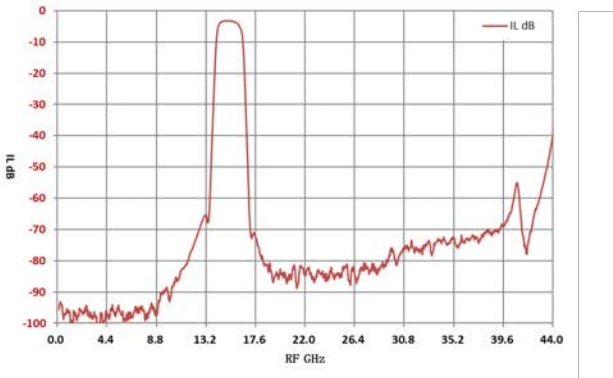
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

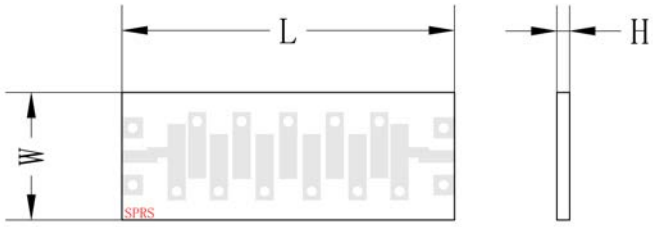
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	16.2	GHz
工作带宽	14.5-17.9	GHz
中心损耗	1.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-12.6GHz	dBc
带外抑制	40@19.9-36.0GHz	dBc

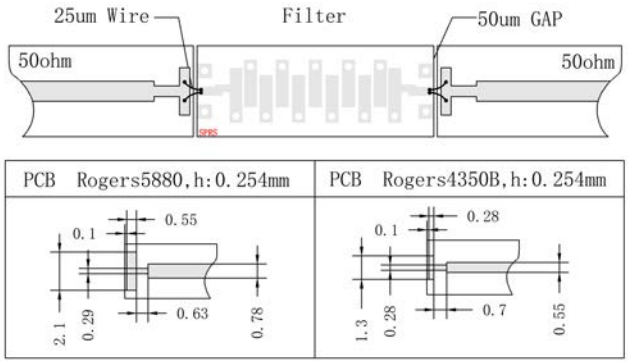
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.6，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



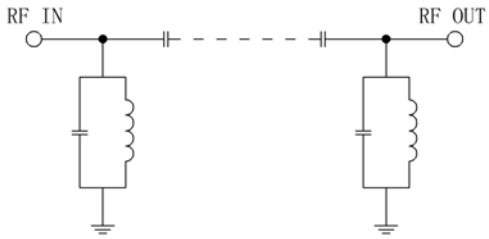
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

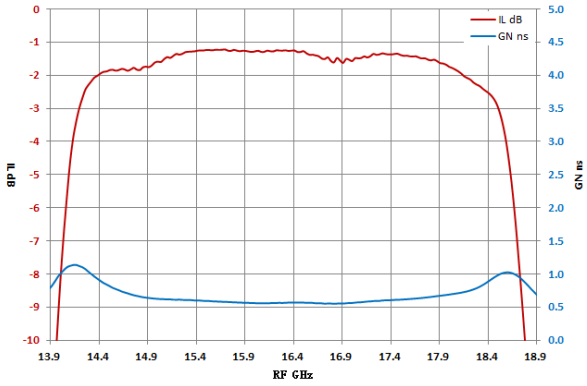
参考实物图

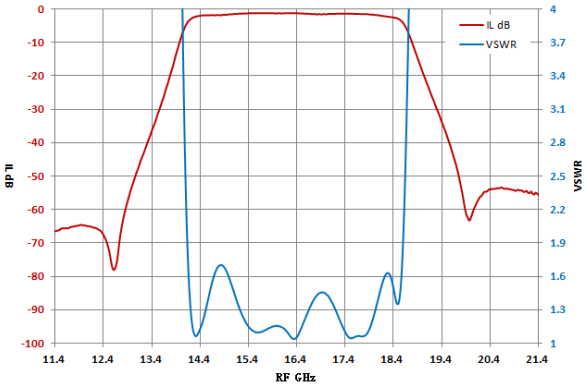


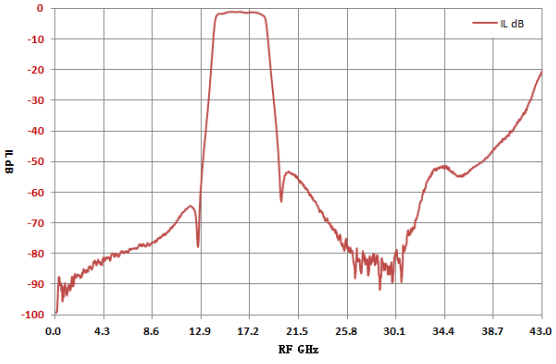
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



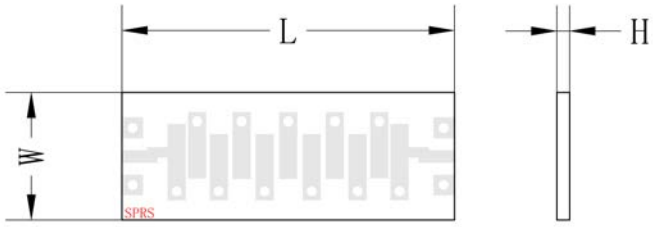
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	16.4	GHz
工作带宽	14.6-18.1	GHz
中心损耗	3.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-11.6GHz	dBc
带外抑制	30@19.5-38.0GHz	dBc

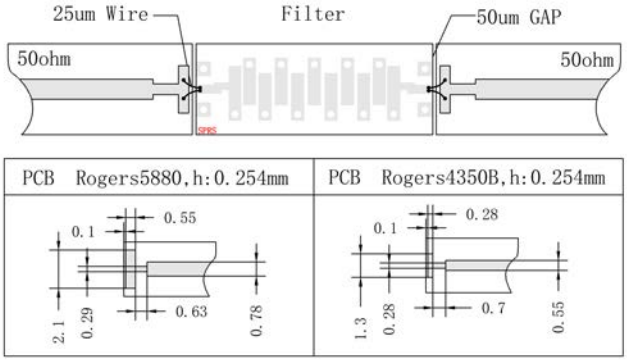
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



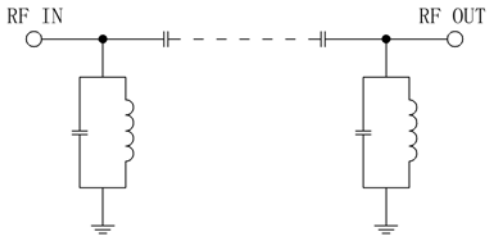
推荐装配图



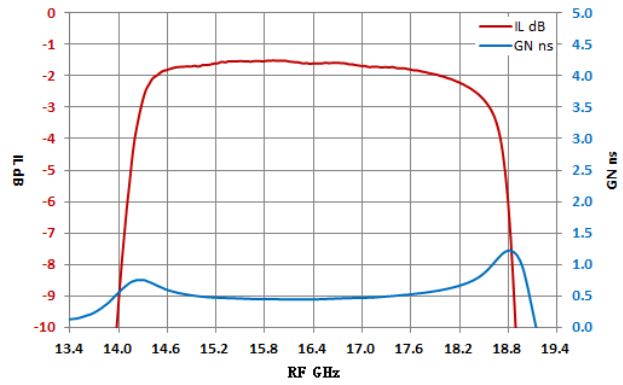
注意事项

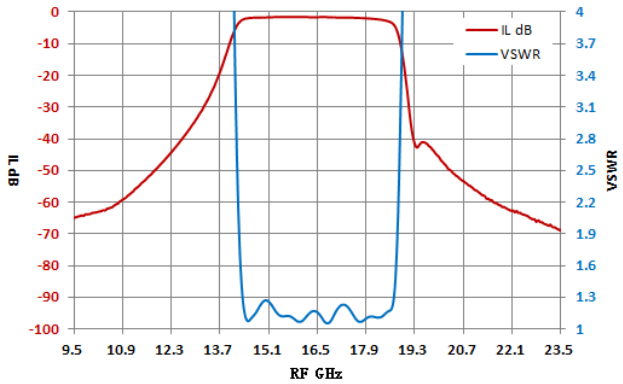
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

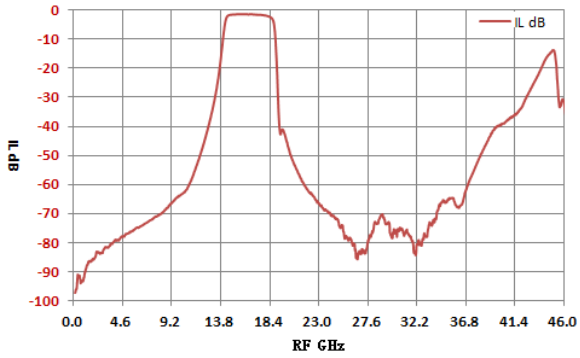
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

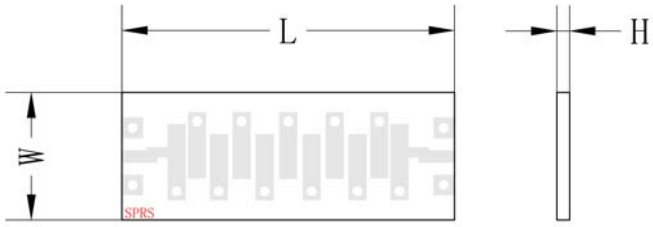
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	16.45	GHz
工作带宽	14.6-18.3	GHz
中心损耗	1.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-12.5GHz	dBc
带外抑制	40@20.0-36.0GHz	dBc

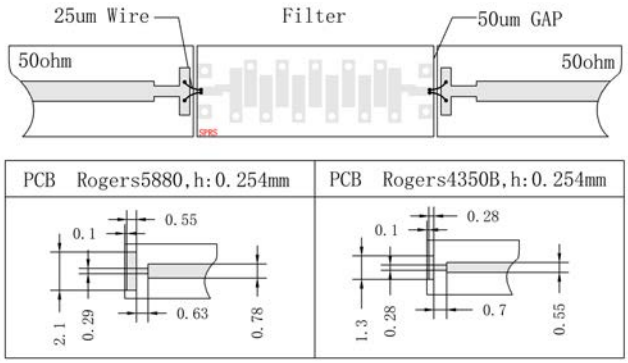
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.6，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



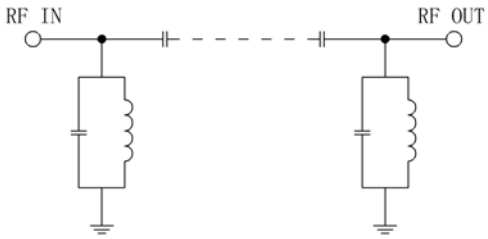
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

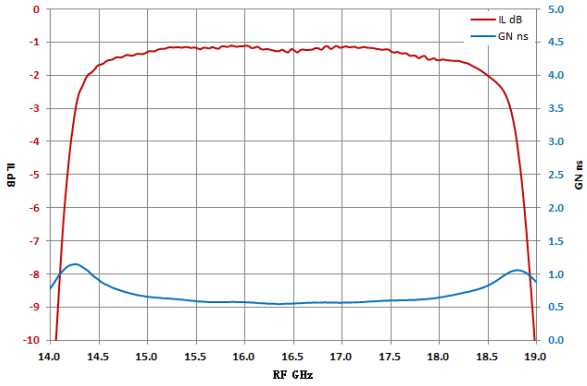
参考实物图

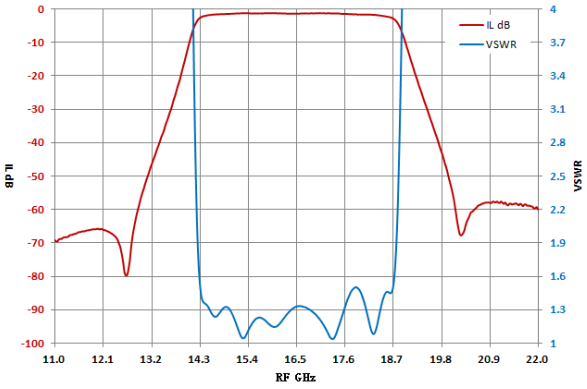


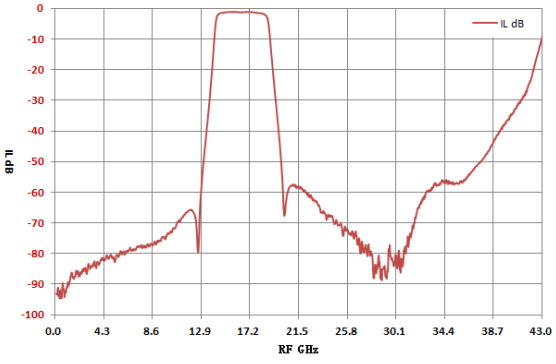
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

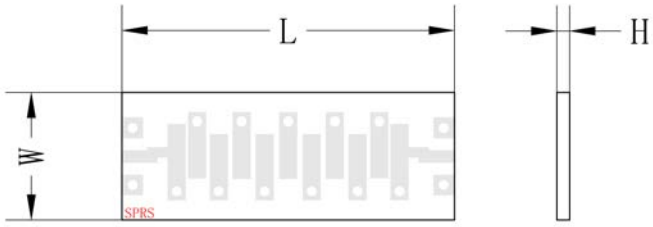
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	16.5	GHz
工作带宽	14.7-18.3	GHz
中心损耗	1.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-12.7GHz	dBc
带外抑制	40@20.5-39.0GHz	dBc

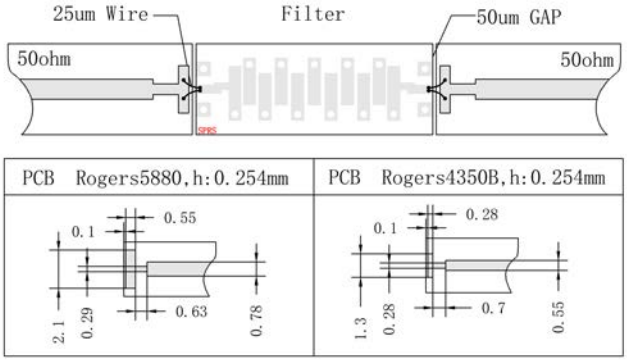
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



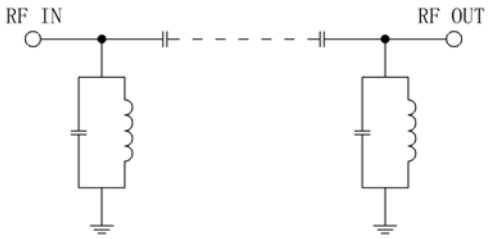
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

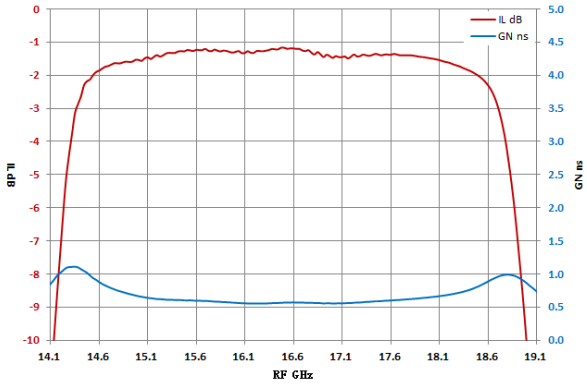
参考实物图

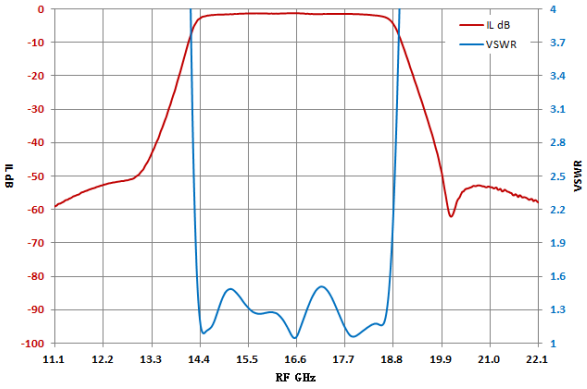


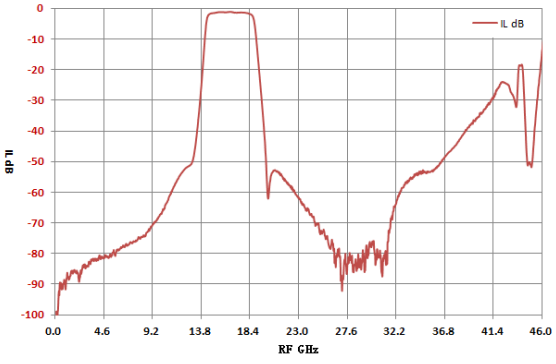
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

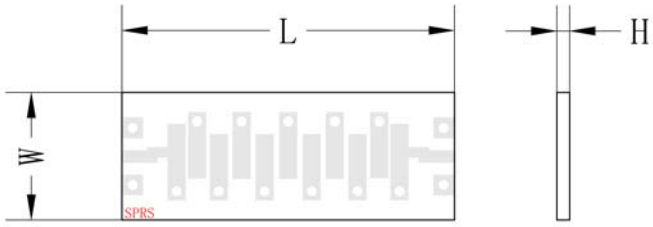
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	17.5	GHz
工作带宽	14.8-20.2	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-13.3GHz	dBc
带外抑制	40@22.0-24.0GHz	dBc

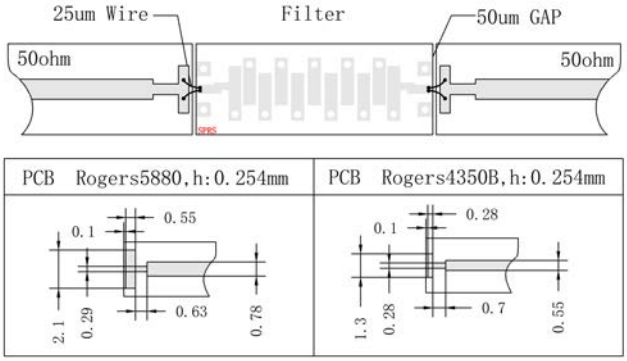
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



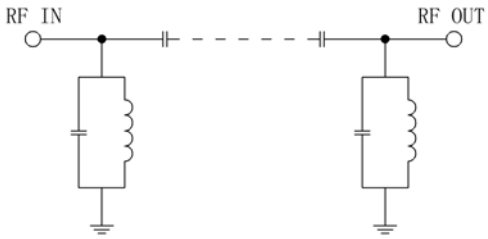
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

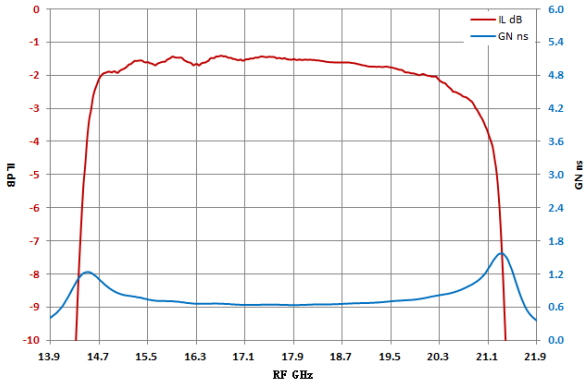
参考实物图

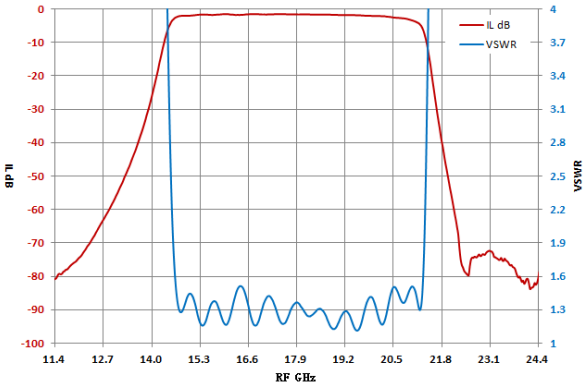


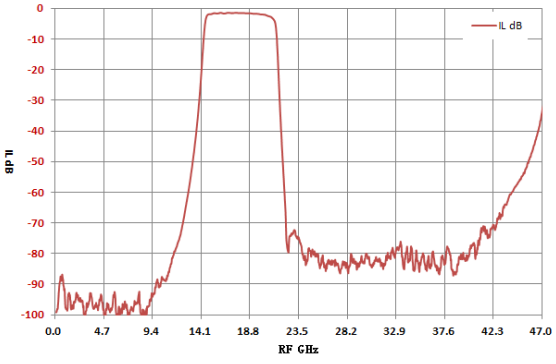
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



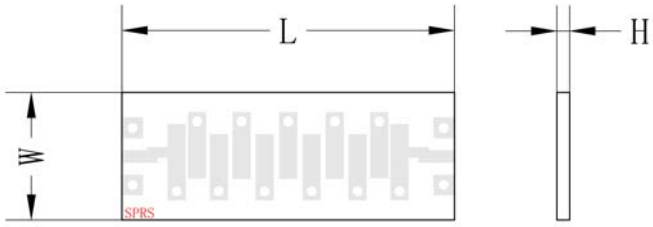
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	17.7	GHz
工作带宽	14.8-20.6	GHz
中心损耗	2.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-13.0GHz	dBc
带外抑制	40@22.7-42.0GHz	dBc

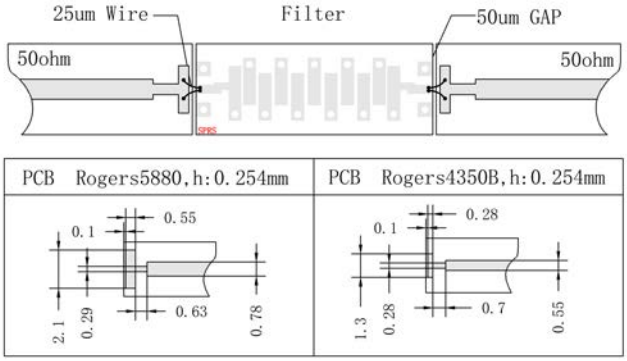
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



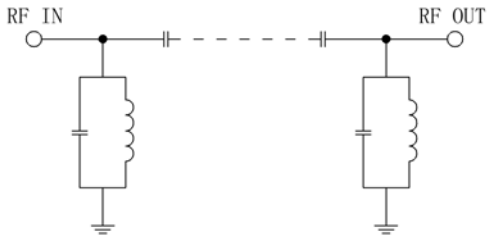
推荐装配图



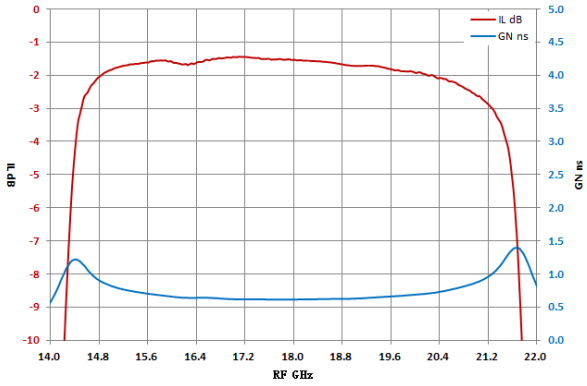
注意事项

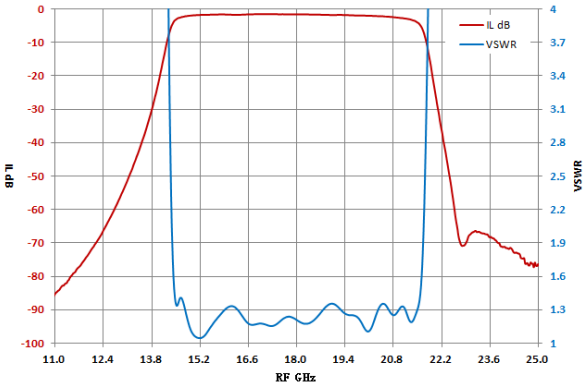
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

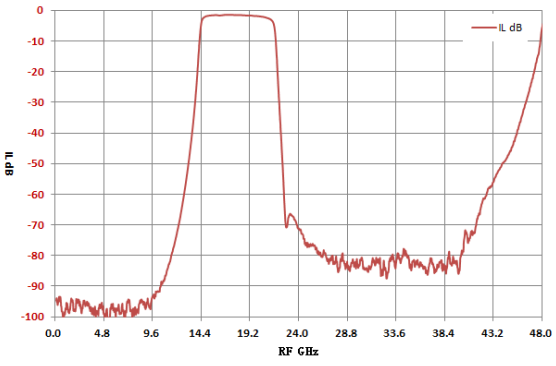
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



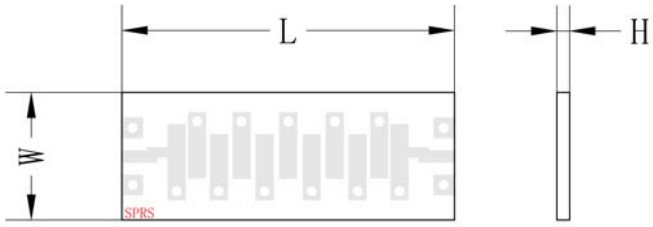
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	16.5	GHz
工作带宽	14.9-18.1	GHz
中心损耗	2.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-13.2GHz	dBc
带外抑制	40@19.9-36.0GHz	dBc

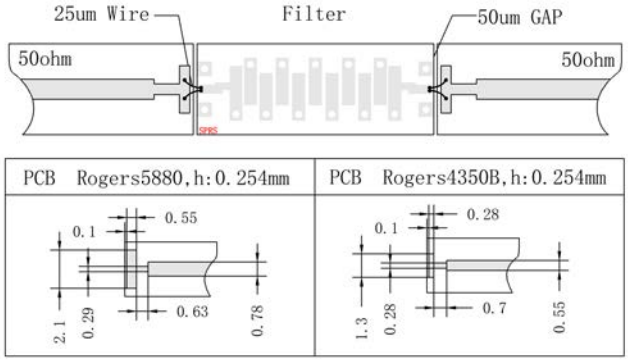
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



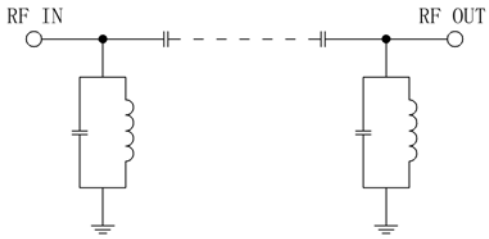
推荐装配图



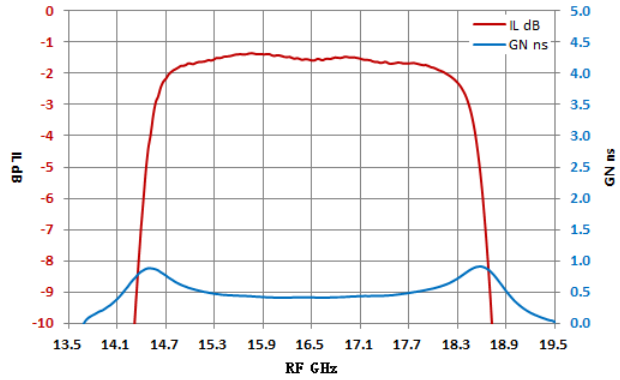
注意事项

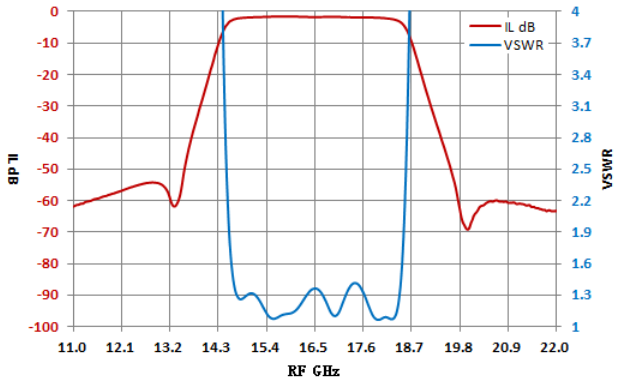
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

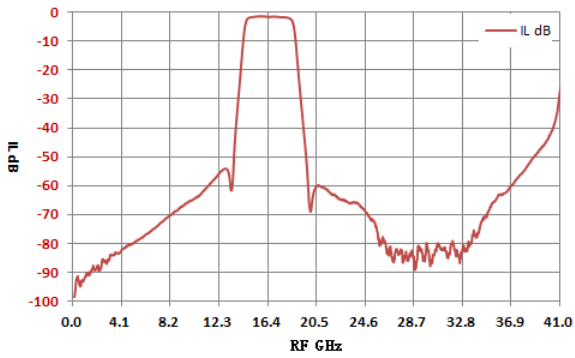
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

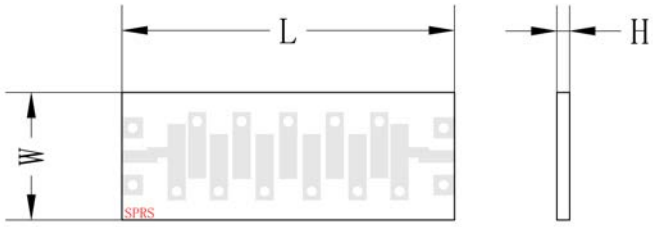
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	16.95	GHz
工作带宽	14.9-19.0	GHz
中心损耗	1.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-12.4GHz	dBc
带外抑制	40@22.0-37.0GHz	dBc

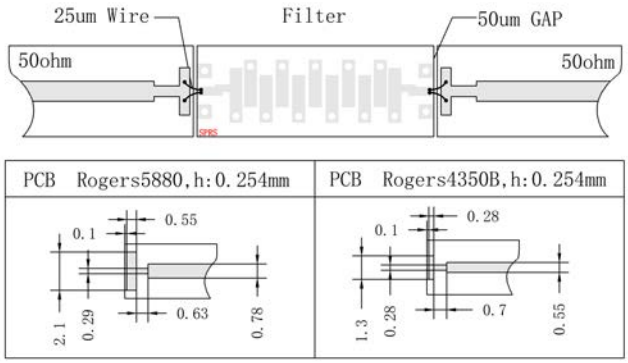
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



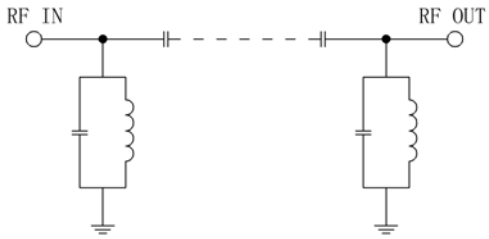
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

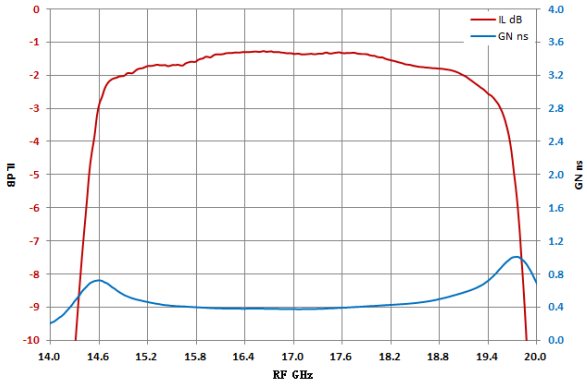
参考实物图

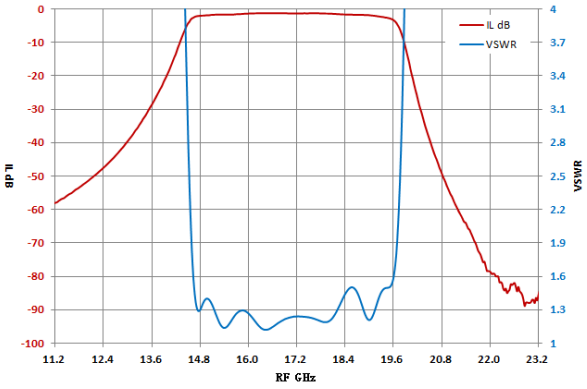


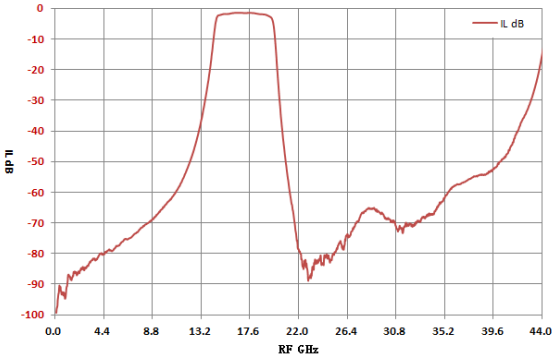
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

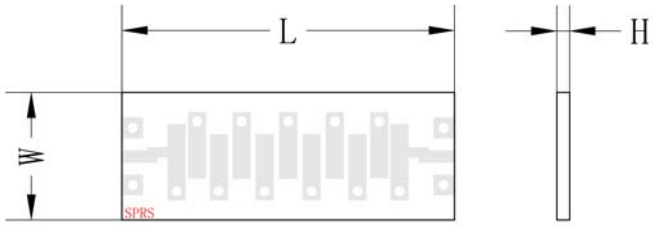
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	17.1	GHz
工作带宽	14.9-19.3	GHz
中心损耗	1.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-11.2GHz	dBc
带外抑制	40@22.4-31.0GHz	dBc

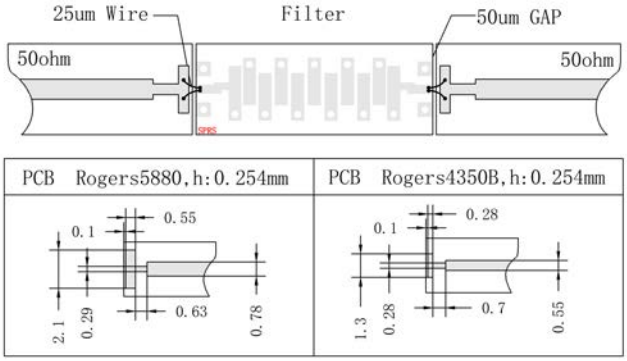
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：2.7，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



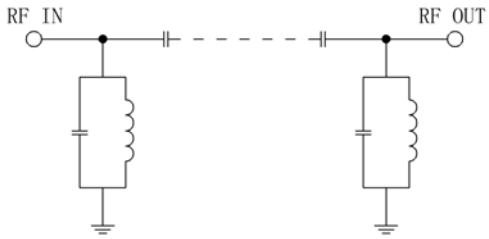
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.87mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

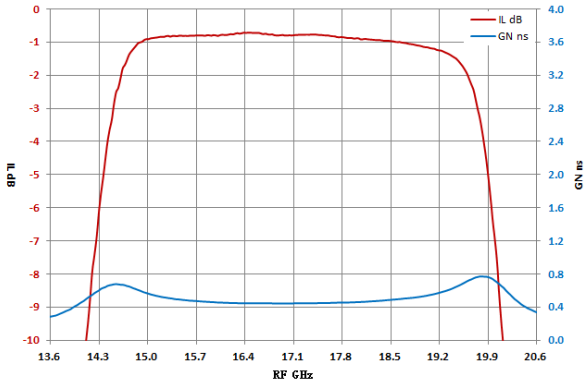
参考实物图

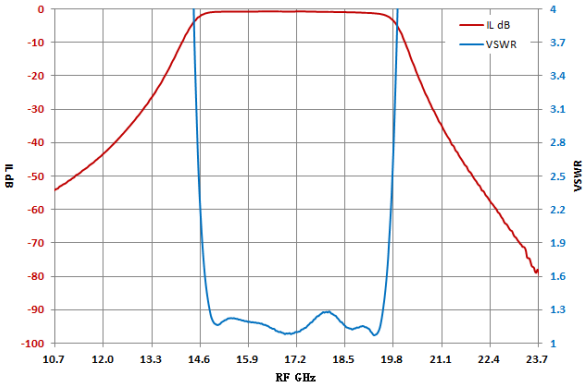


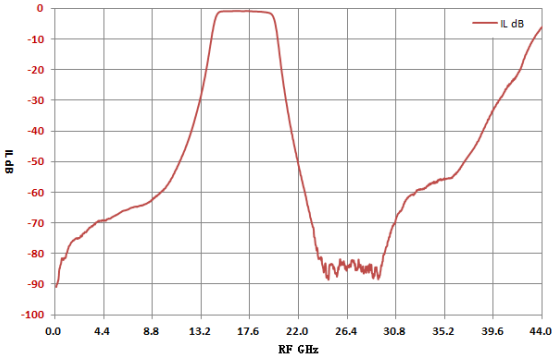
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



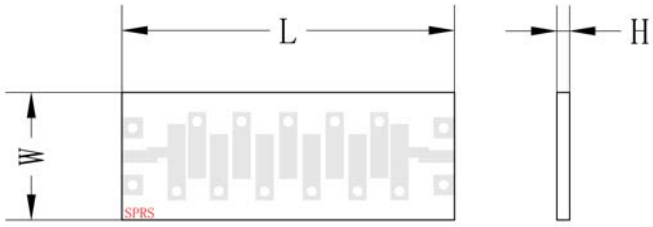
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	17.5	GHz
工作带宽	14.9-20.1	GHz
中心损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-12.8GHz	dBc
带外抑制	40@22.3-46.0GHz	dBc

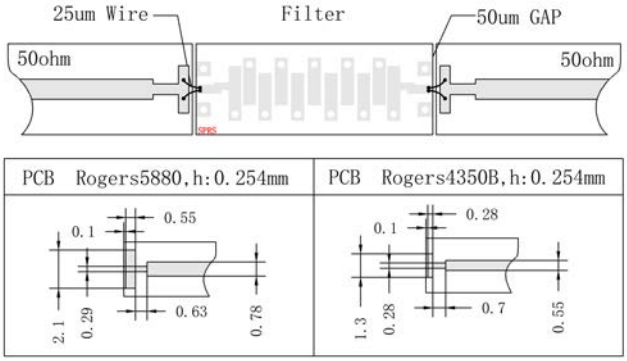
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



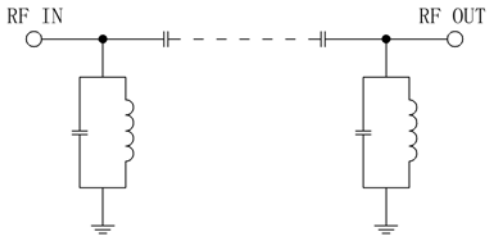
推荐装配图



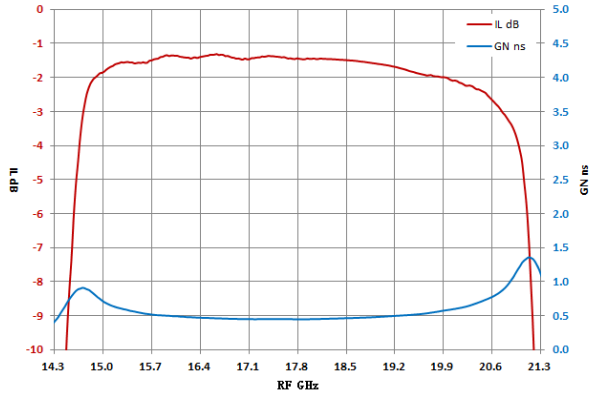
注意事项

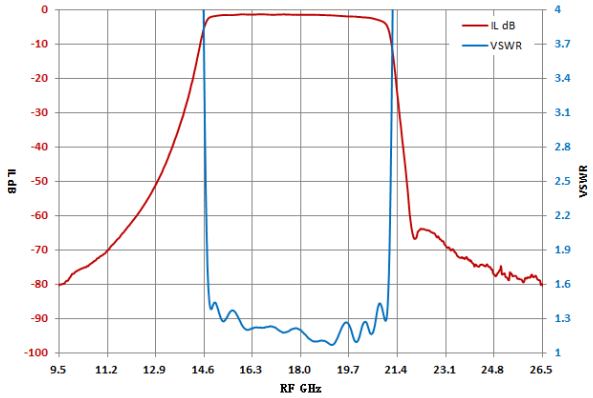
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

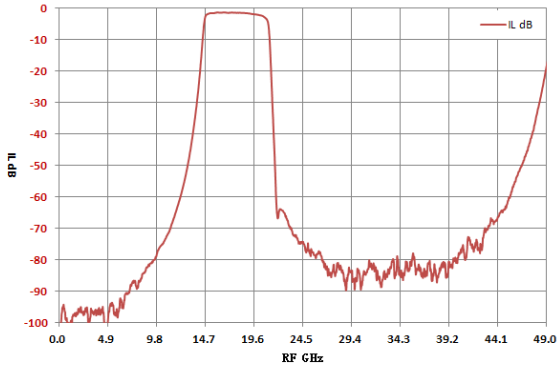
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



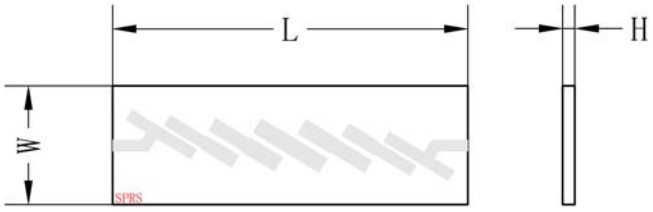
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	15.0	GHz
工作带宽	0	GHz
中心损耗	7.0	dB
带内波动	0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0	ns
带外抑制	40@DC-14.4GHz	dBc
带外抑制	40@15.6-22.0GHz	dBc

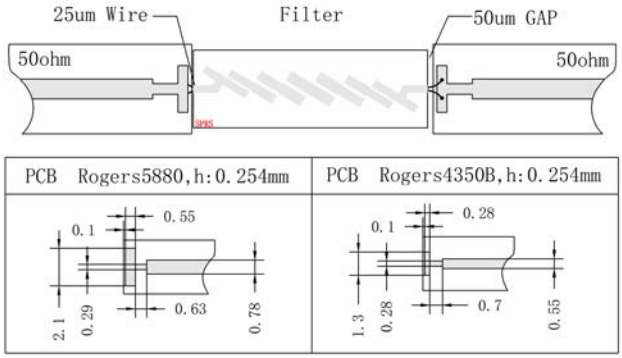
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



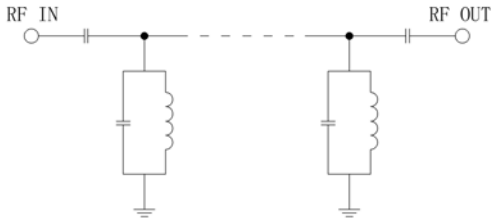
推荐装配图



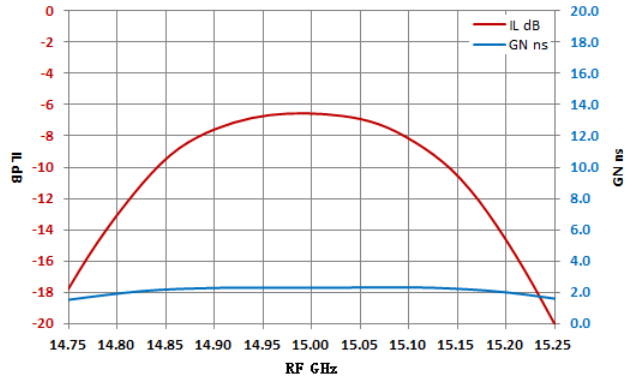
注意事项

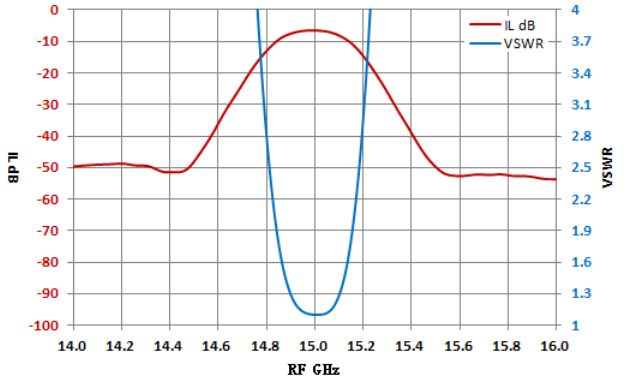
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

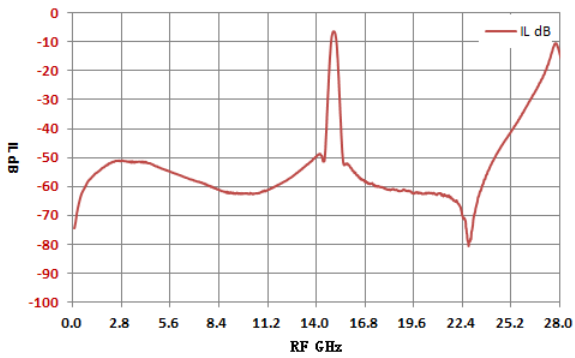
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



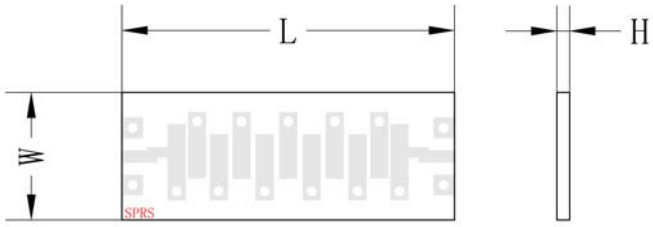
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	15.8	GHz
工作带宽	15.0-16.6	GHz
中心损耗	3.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-13.7GHz	dBc
带外抑制	40@17.9-39.0GHz	dBc

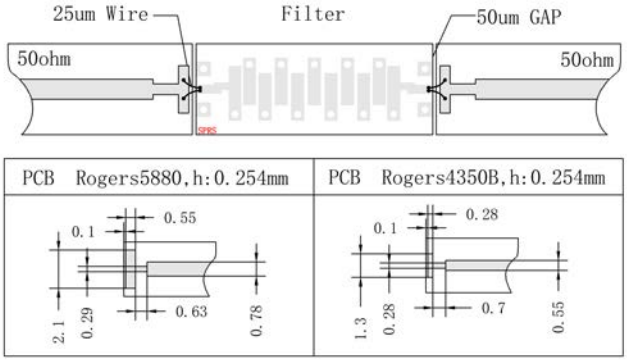
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



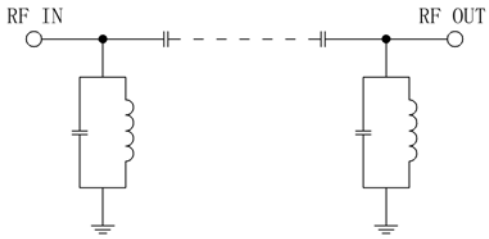
推荐装配图



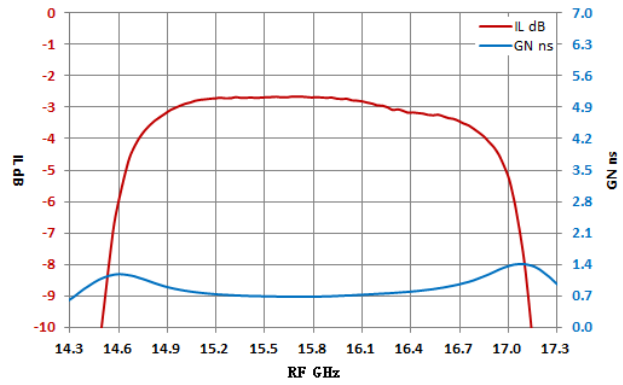
注意事项

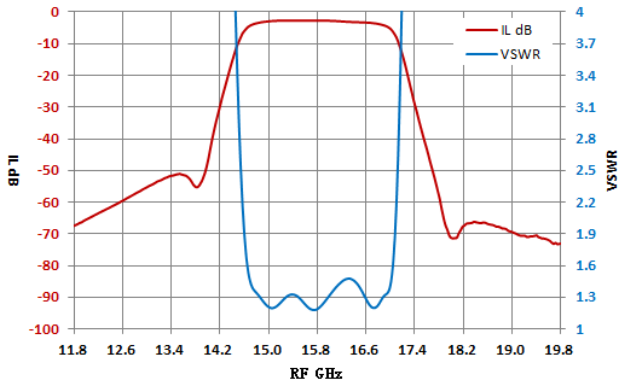
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

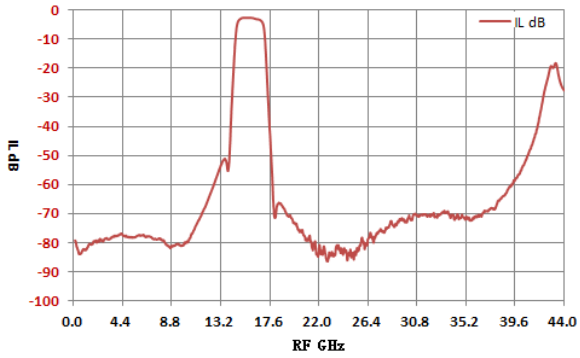
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

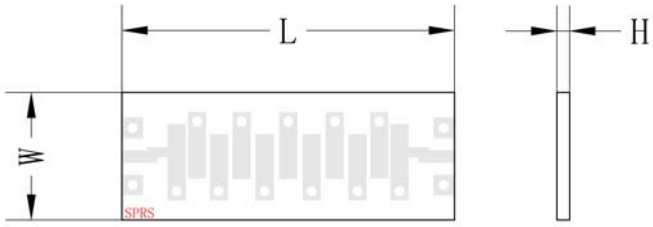
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	16	GHz
工作带宽	15.0-17.0	GHz
中心损耗	2.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-12.8GHz	dBc
带外抑制	40@19.2-37.0GHz	dBc

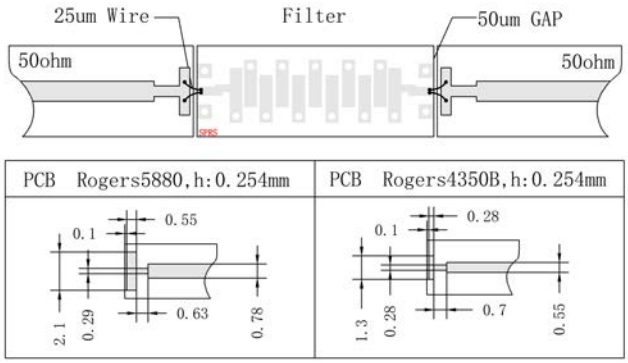
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



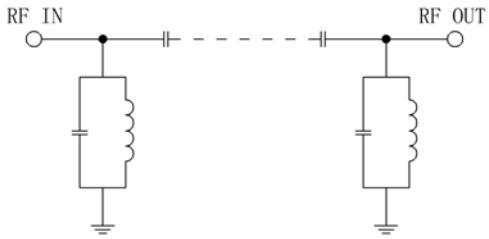
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

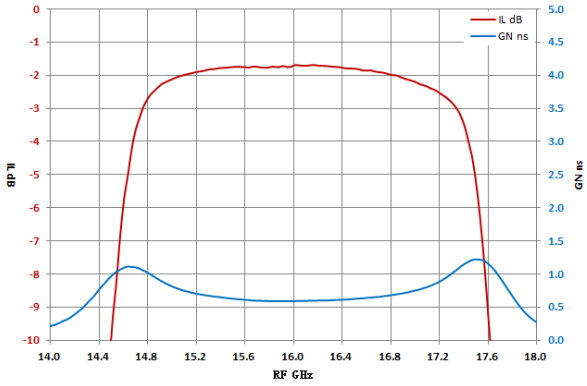
参考实物图

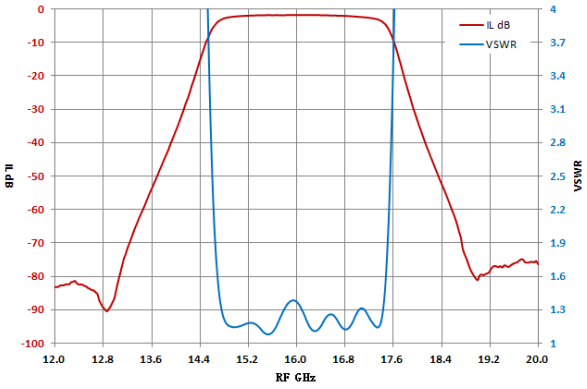


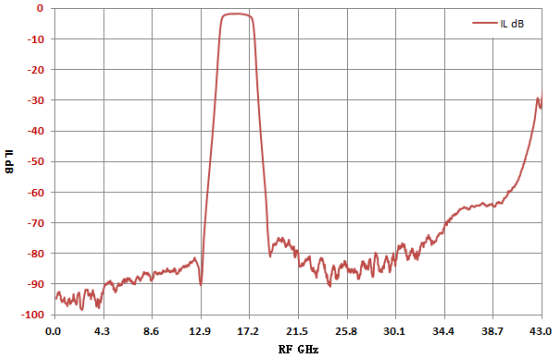
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



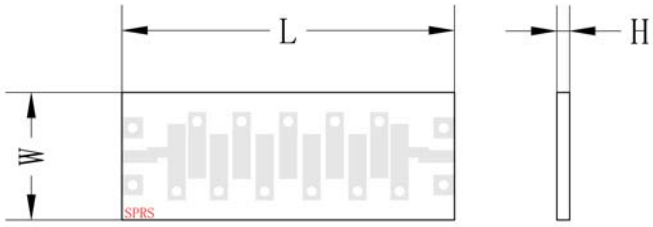
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	16.7	GHz
工作带宽	15.0-18.4	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-13.6GHz	dBc
带外抑制	40@20.2-36.0GHz	dBc

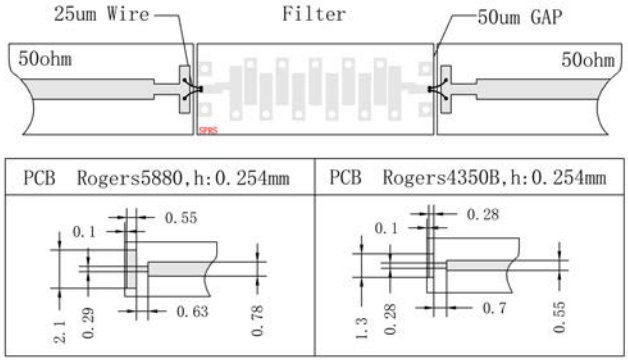
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



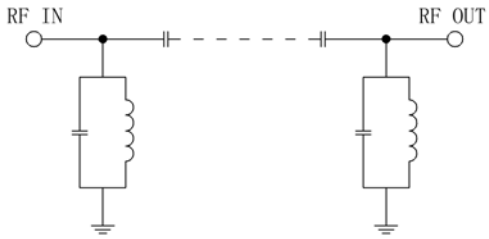
推荐装配图



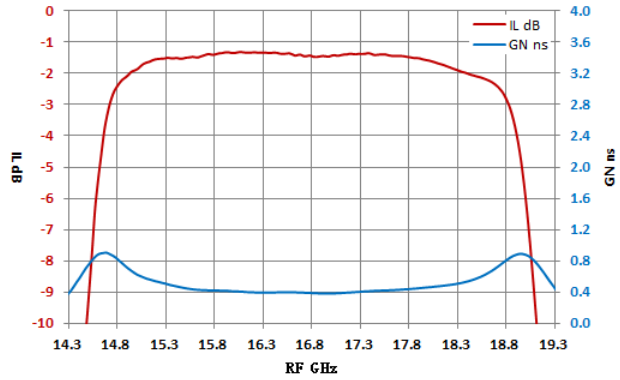
注意事项

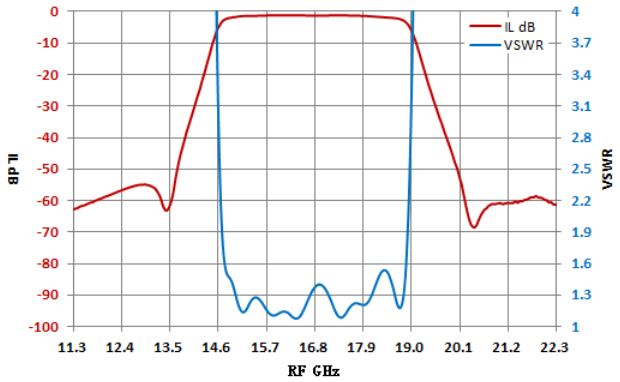
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

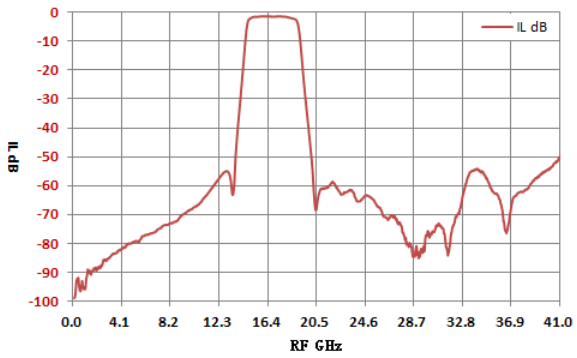
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



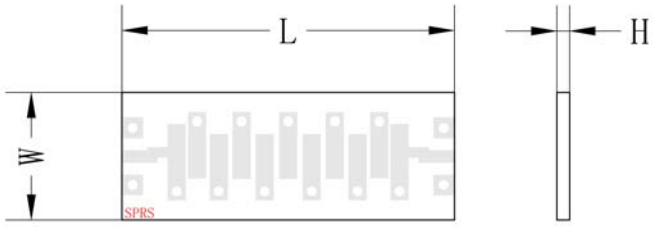
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	16.8	GHz
工作带宽	15.0-18.6	GHz
中心损耗	1.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-13.3GHz	dBc
带外抑制	40@20.8-36.0GHz	dBc

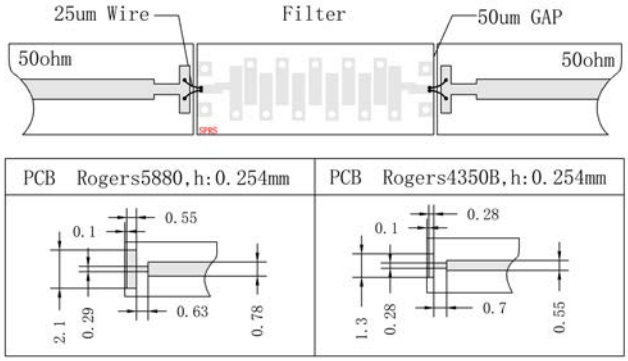
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



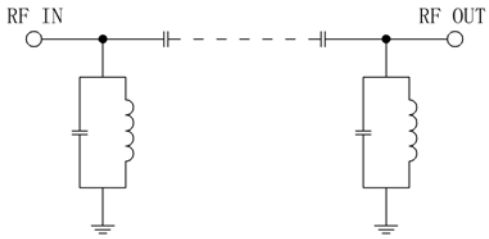
推荐装配图



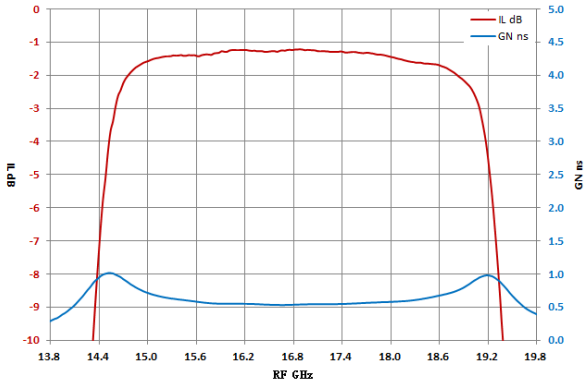
注意事项

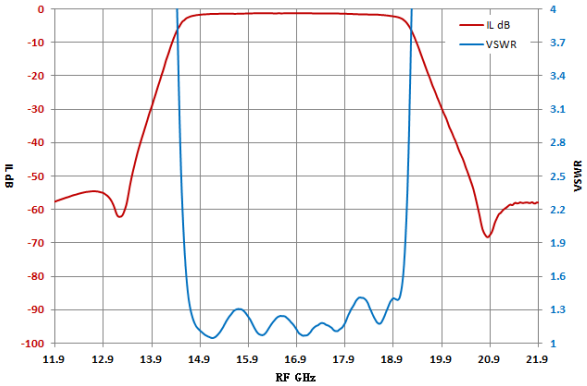
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

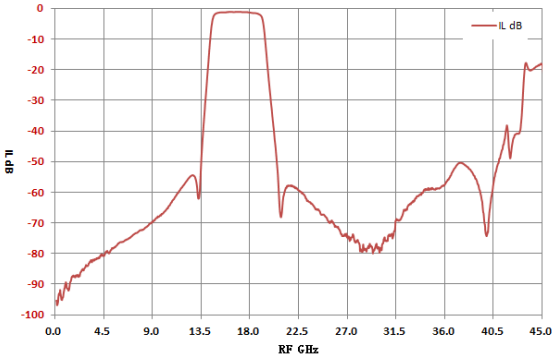
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



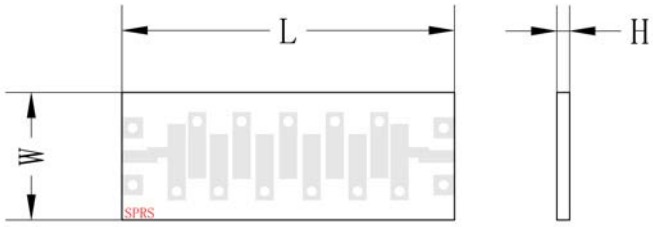
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	17.4	GHz
工作带宽	15.0-19.8	GHz
中心损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-13.2GHz	dBc
带外抑制	40@22.0-41.0GHz	dBc

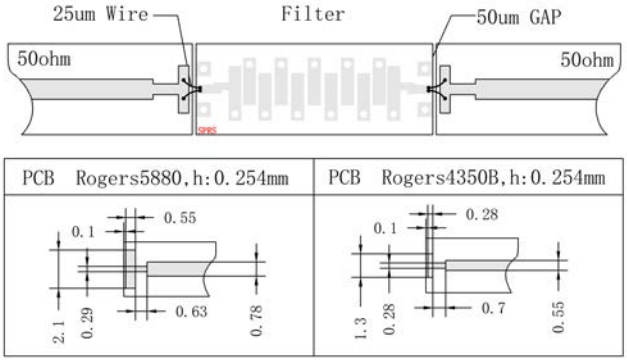
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



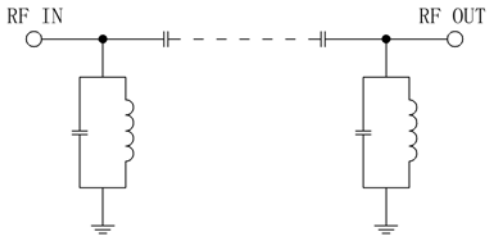
推荐装配图



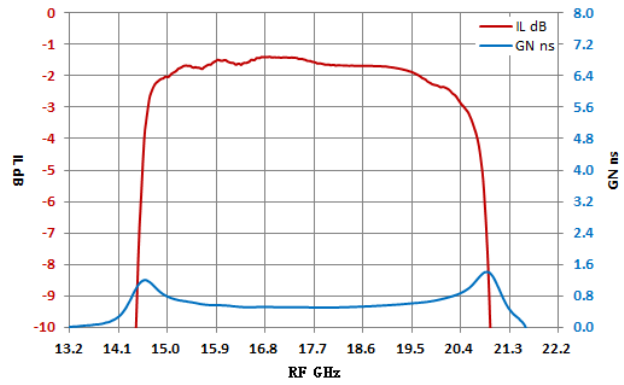
注意事项

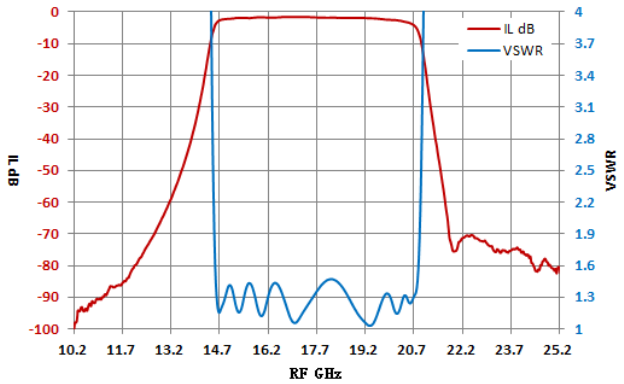
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

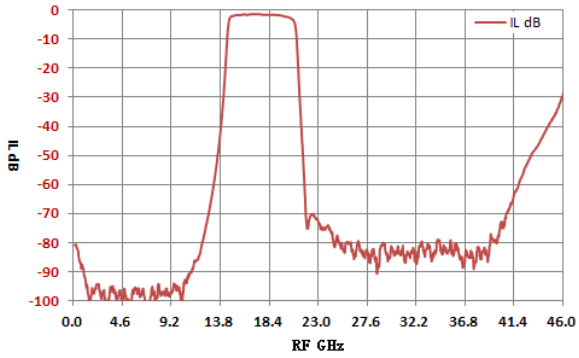
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

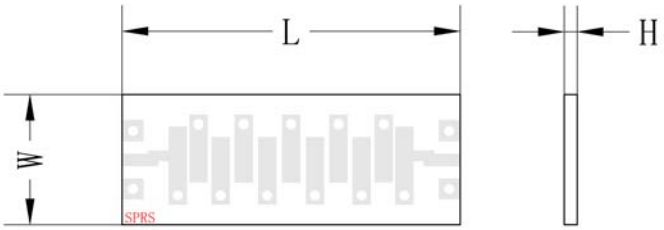
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	15.1	GHz
工作带宽	15.05-15.15	GHz
中心损耗	5.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-14.2GHz	dBc
带外抑制	40@15.8-40.0GHz	dBc

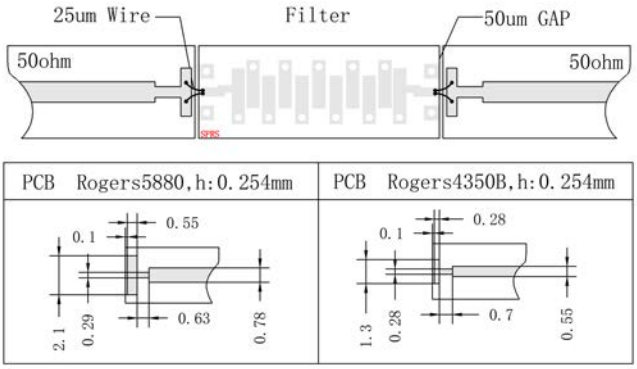
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

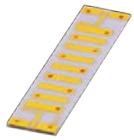
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

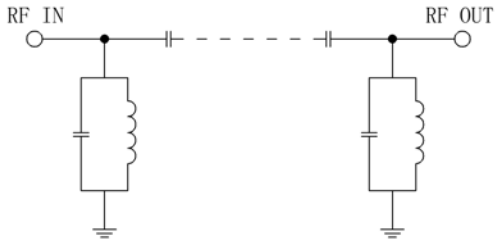
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

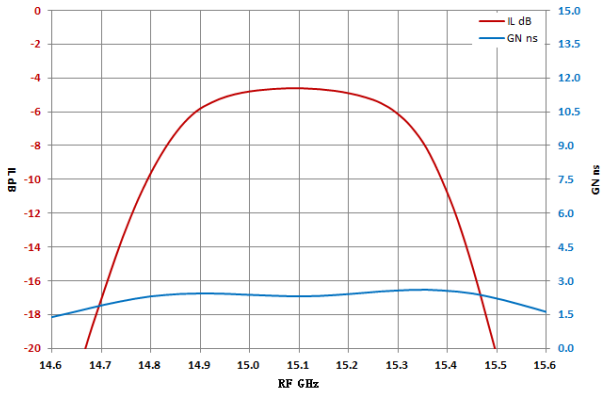
参考图

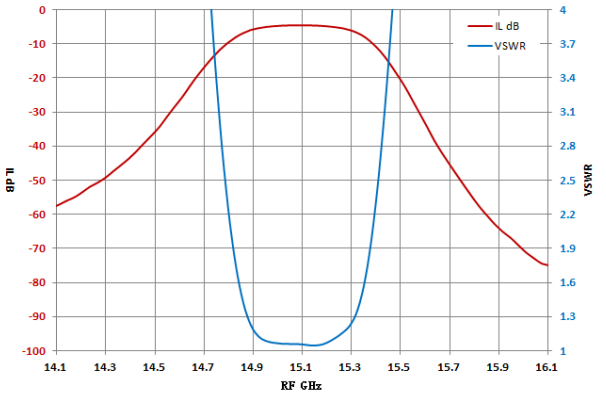


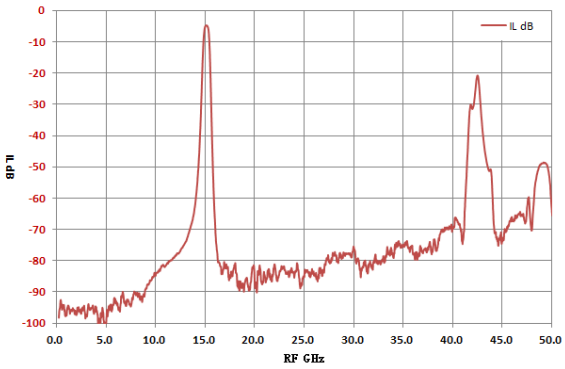
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



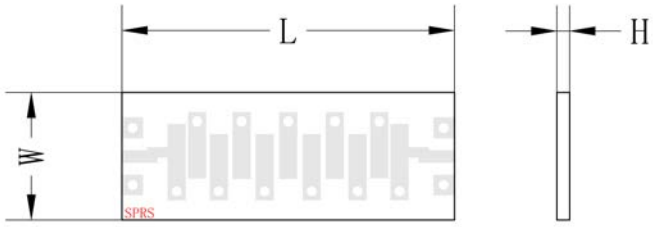
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	16.1	GHz
工作带宽	15.2-16.9	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-14.0GHz	dBc
带外抑制	40@18.1-42.0GHz	dBc

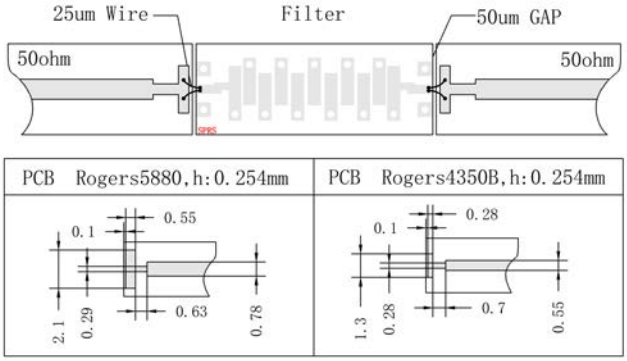
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



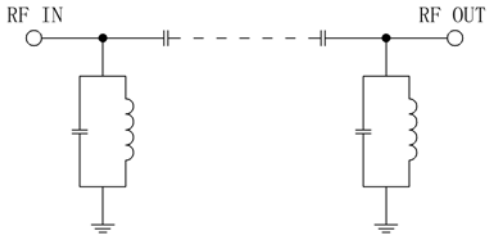
推荐装配图



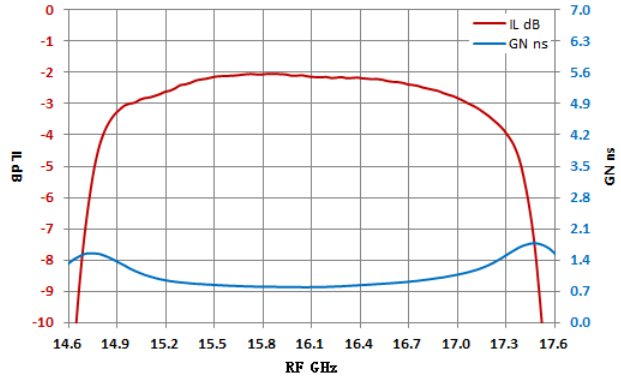
注意事项

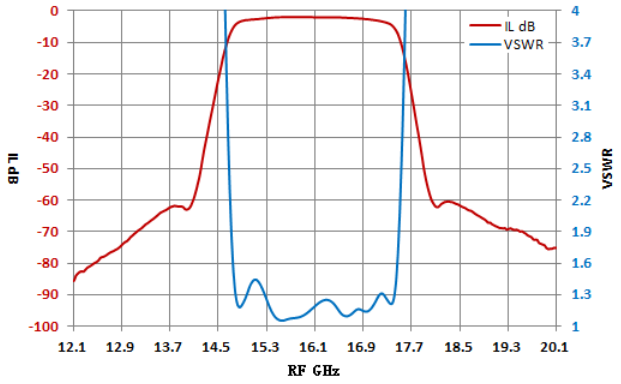
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

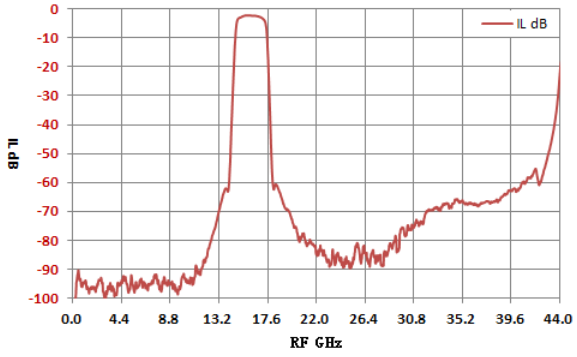
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



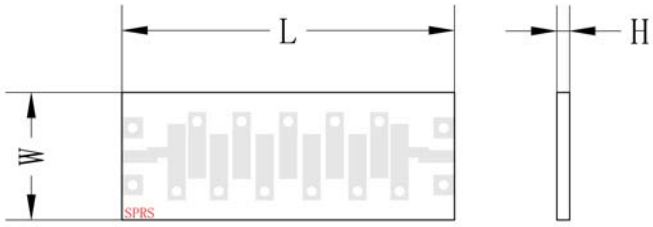
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	16.5	GHz
工作带宽	15.2-17.8	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-13.8GHz	dBc
带外抑制	40@19.3-37.0GHz	dBc

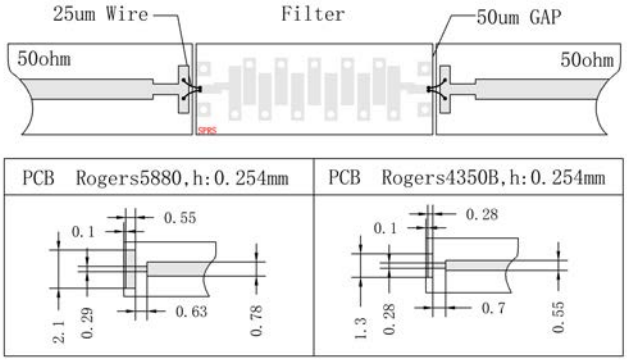
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



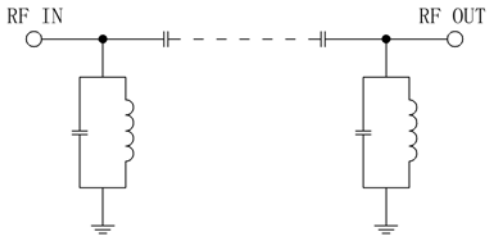
推荐装配图



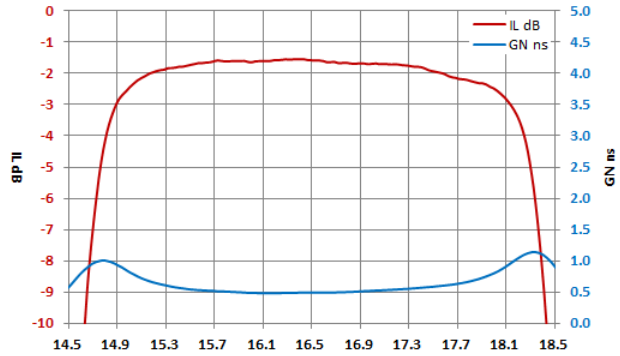
注意事项

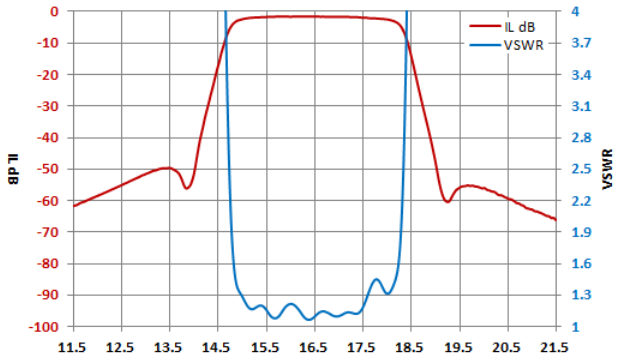
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

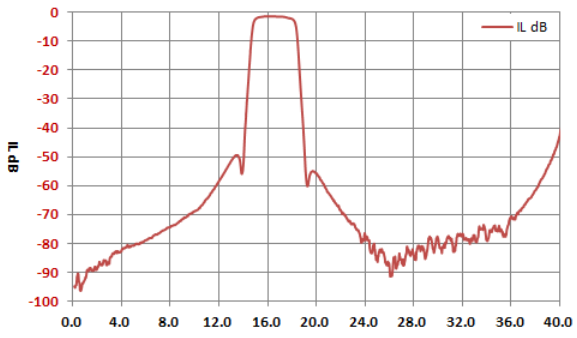
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

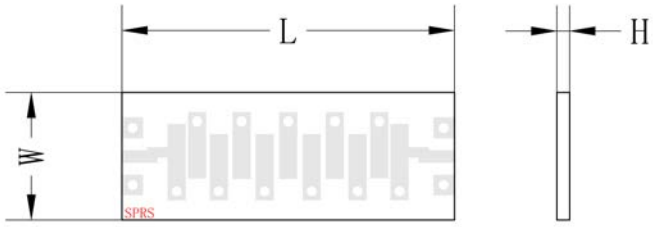
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	17.7	GHz
工作带宽	15.2-20.2	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-12.6GHz	dBc
带外抑制	40@22.2-40.0GHz	dBc

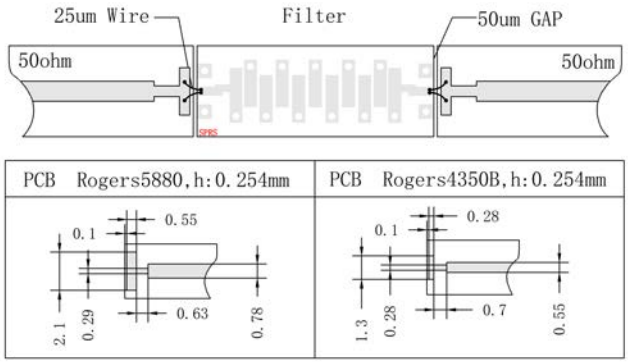
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



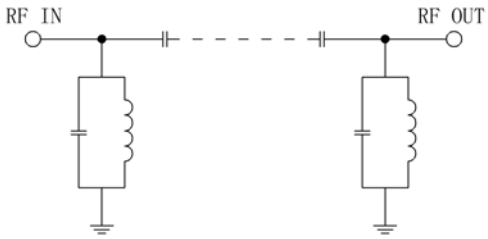
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

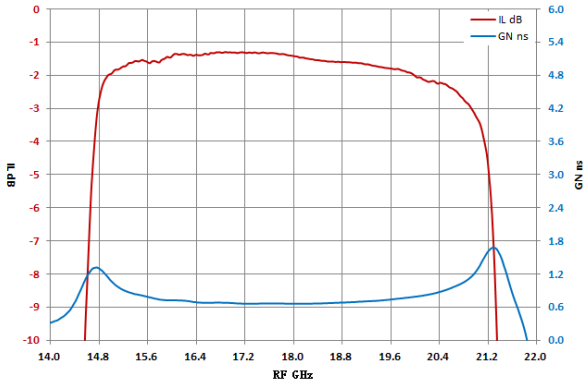
参考实物图

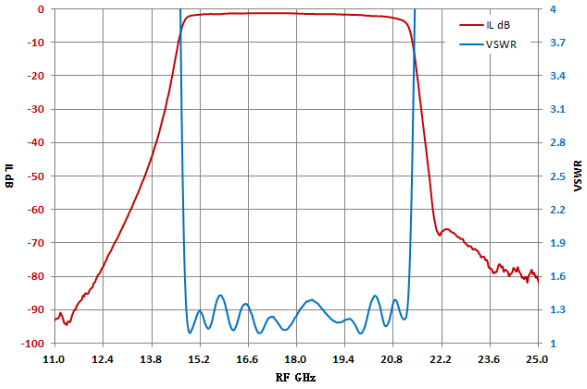


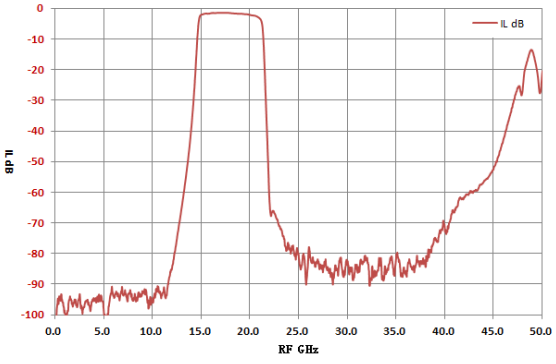
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



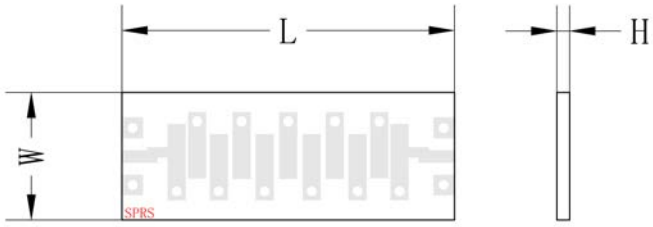
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	15.8	GHz
工作带宽	15.3-16.3	GHz
中心损耗	3.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-14.2GHz	dBc
带外抑制	40@17.5-37.0GHz	dBc

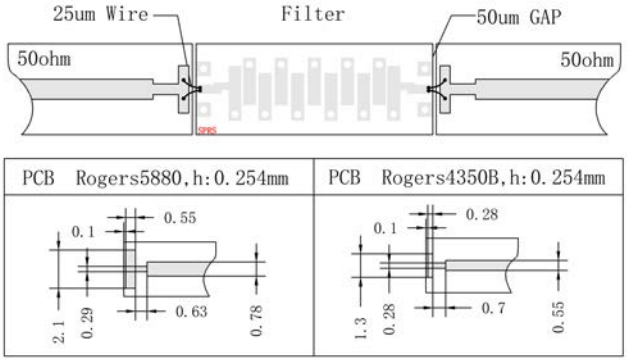
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：10.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



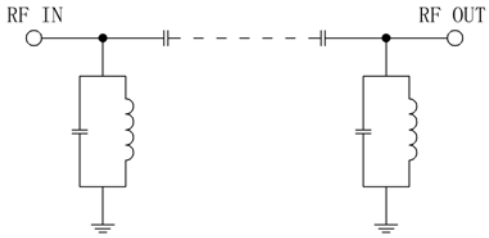
推荐装配图



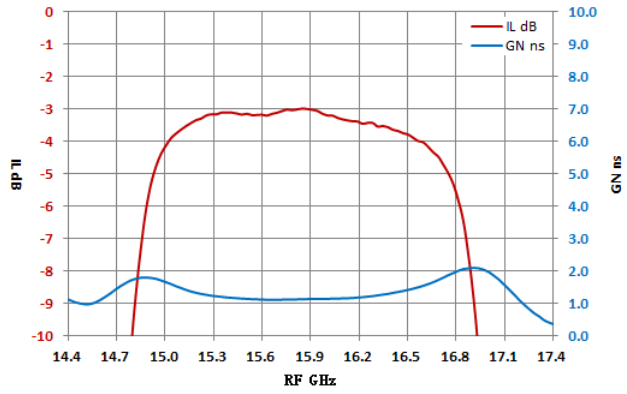
注意事项

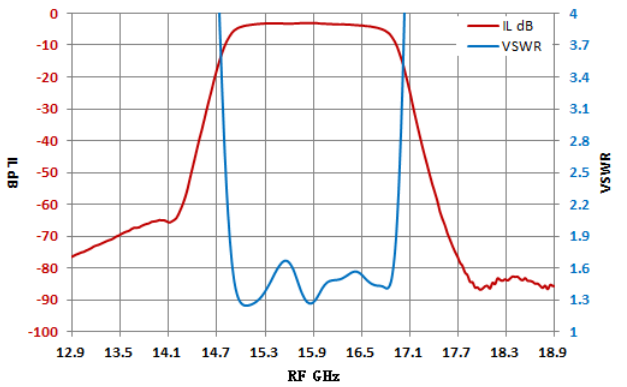
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

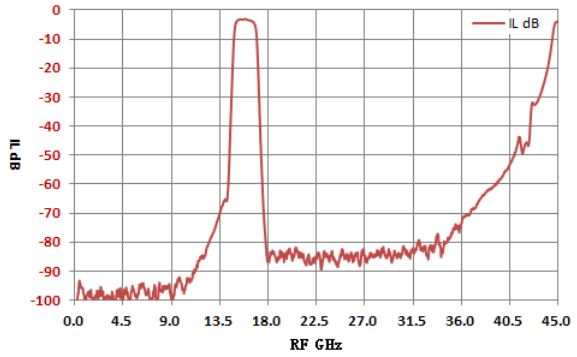
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

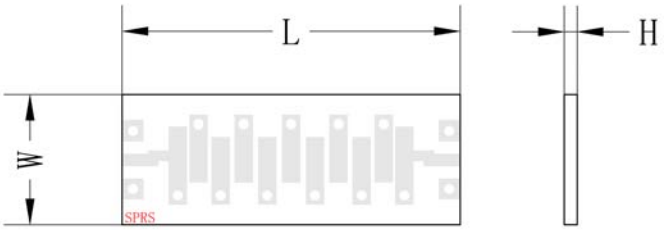
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	17.9	GHz
工作带宽	15.3-20.5	GHz
中心损耗	2.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	60@DC-12.6GHz	dBc
带外抑制	60@22.3-41.0GHz	dBc

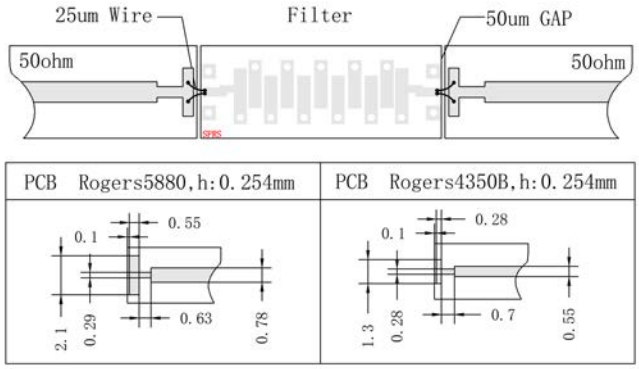
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：8.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

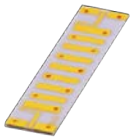
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

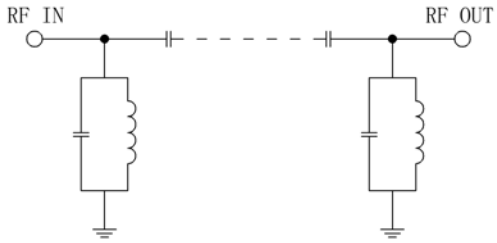
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

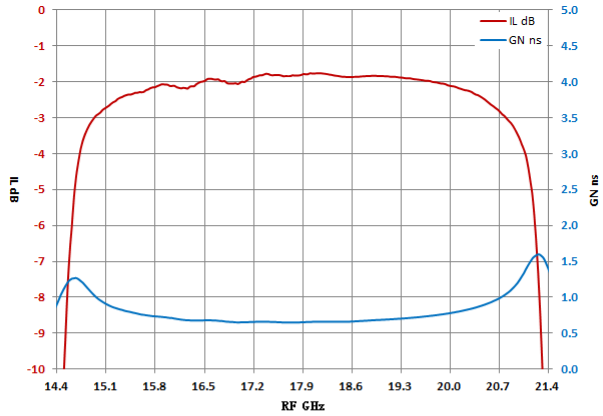
参考图

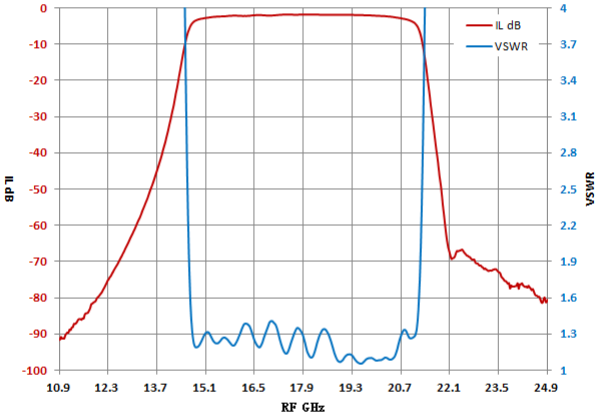


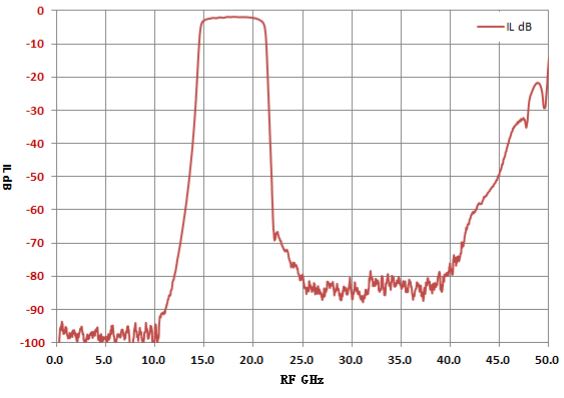
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



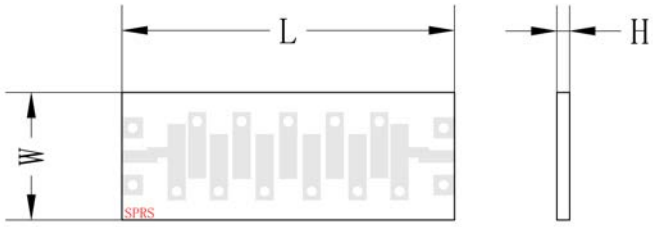
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	16.5	GHz
工作带宽	15.4-17.6	GHz
中心损耗	3.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-14.2GHz	dBc
带外抑制	40@19.0-42.0GHz	dBc

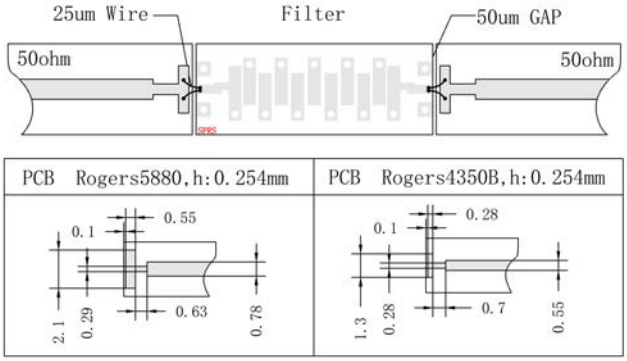
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



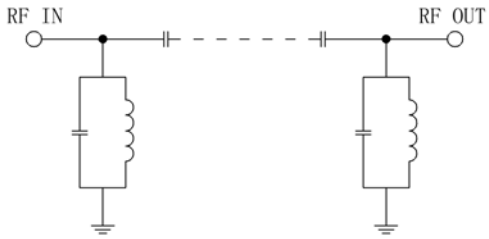
推荐装配图



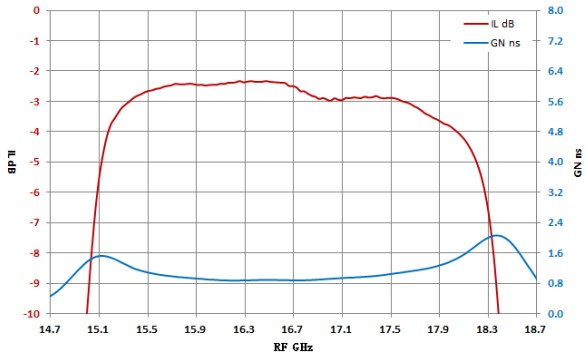
注意事项

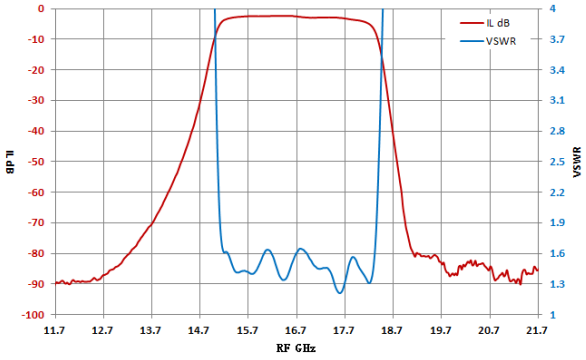
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

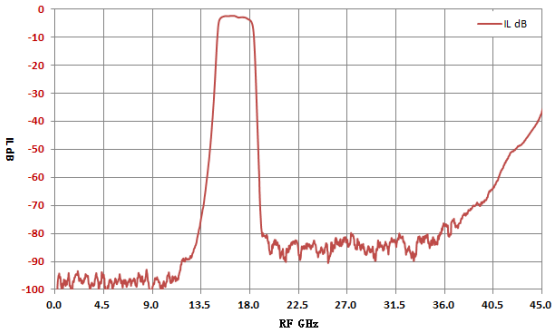
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

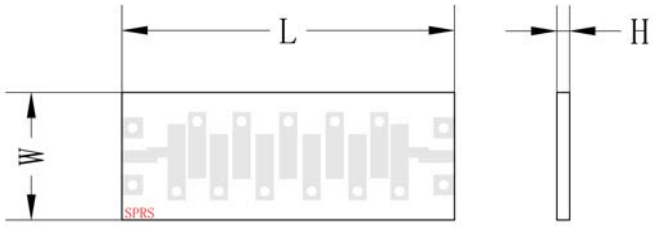
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	17.0	GHz
工作带宽	15.4-18.6	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-13.2GHz	dBc
带外抑制	40@21.1-39.0GHz	dBc

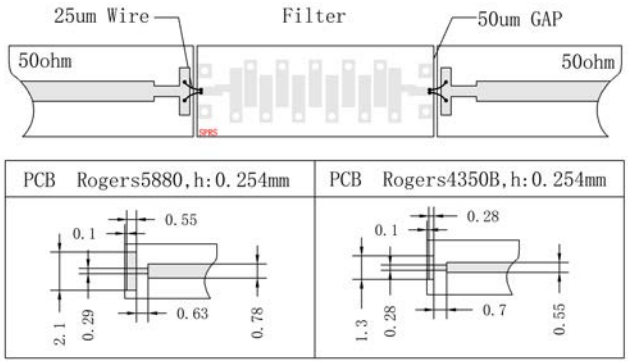
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



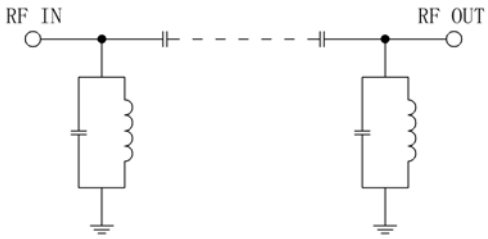
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.87mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

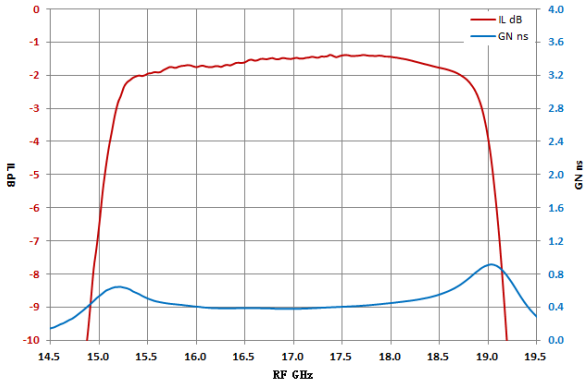
参考实物图

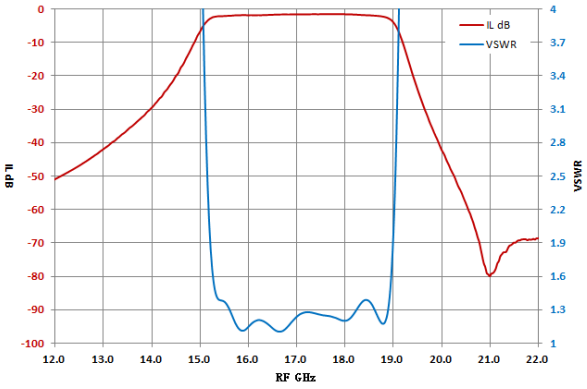


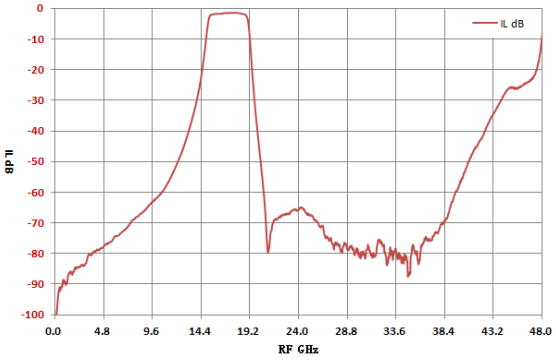
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



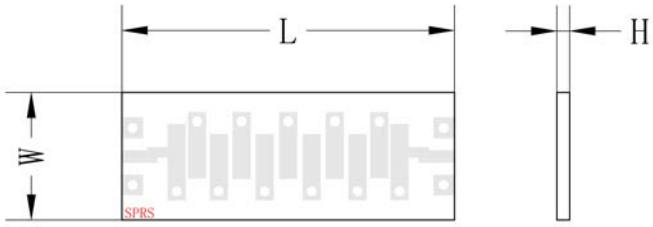
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	17.2	GHz
工作带宽	15.4-19.0	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-12.4GHz	dBc
带外抑制	40@21.2-39.0GHz	dBc

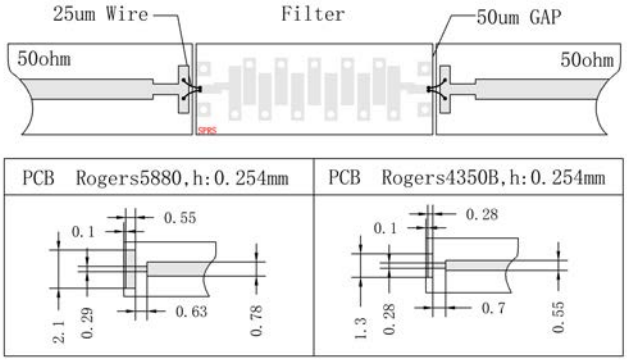
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



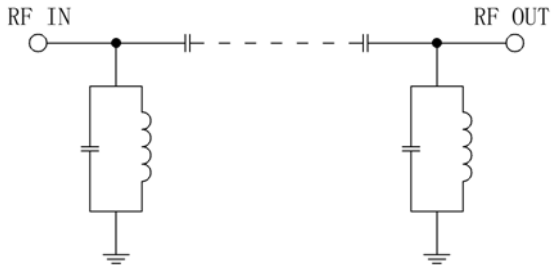
推荐装配图



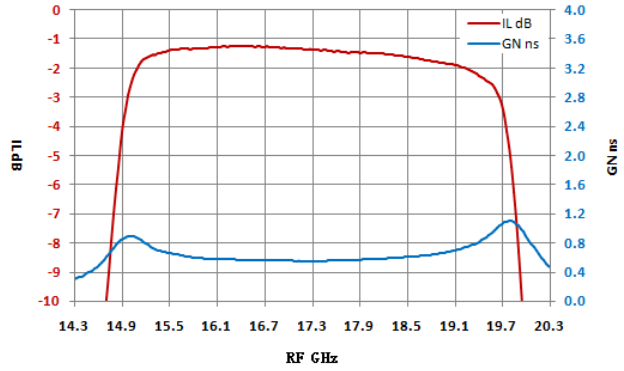
注意事项

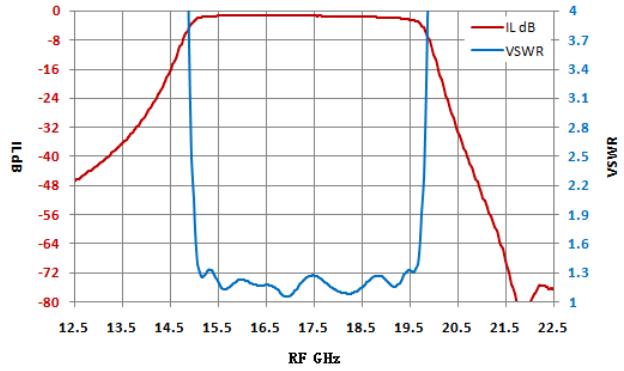
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

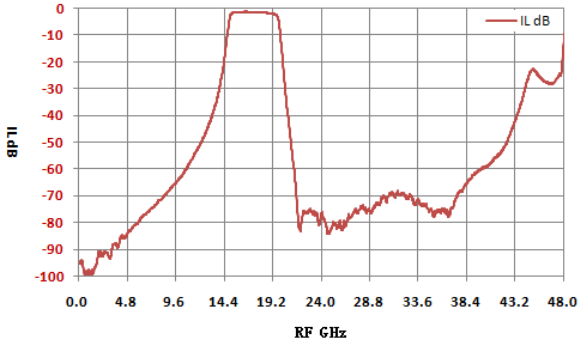
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

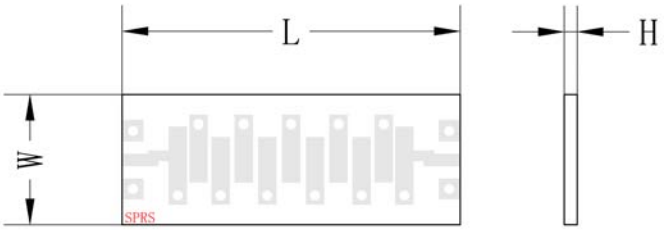
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	18.2	GHz
工作带宽	15.4-21.0	GHz
中心损耗	1.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	60@DC-12.5GHz	dBc
带外抑制	50@24.2-42.0GHz	dBc

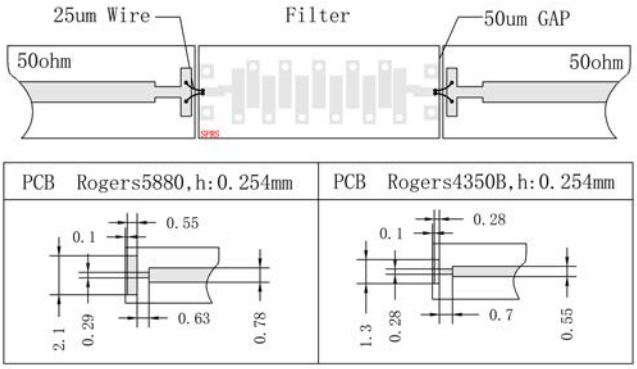
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

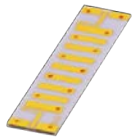
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

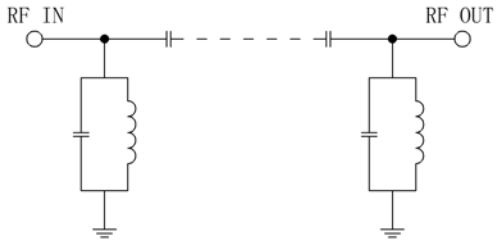
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

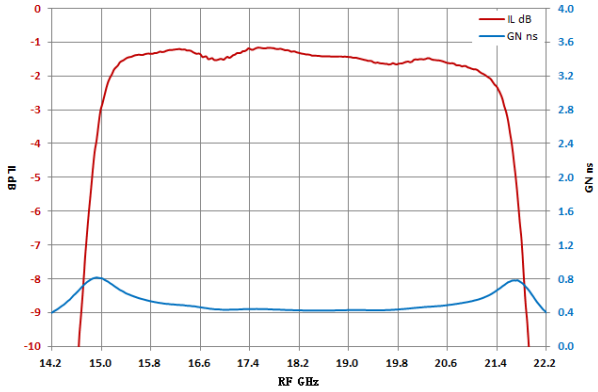
参考图

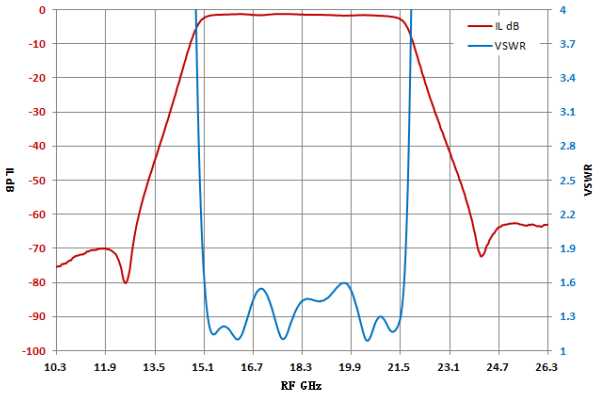


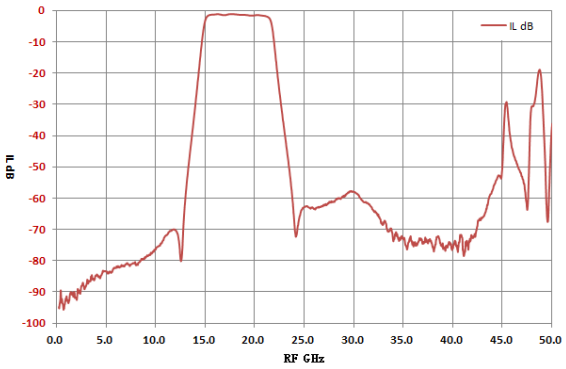
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

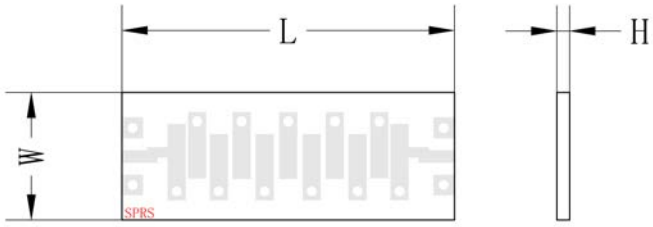
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	16.2	GHz
工作带宽	15.5-16.9	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-14.0GHz	dBc
带外抑制	40@18.5-39.0GHz	dBc

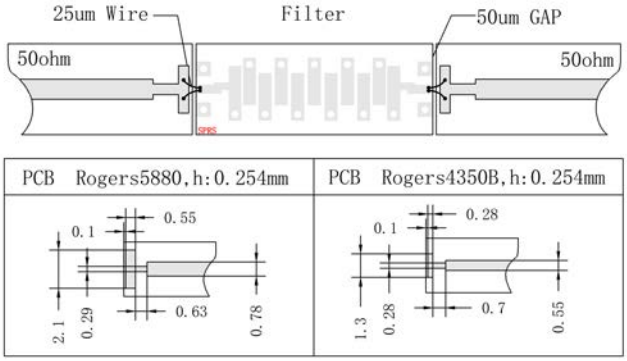
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



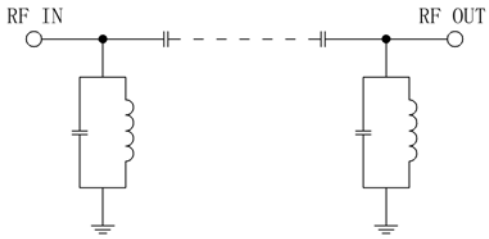
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

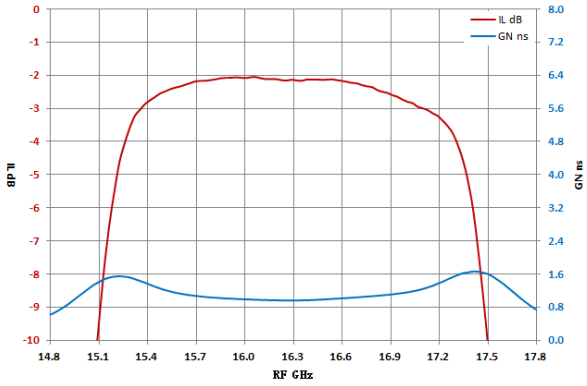
参考实物图

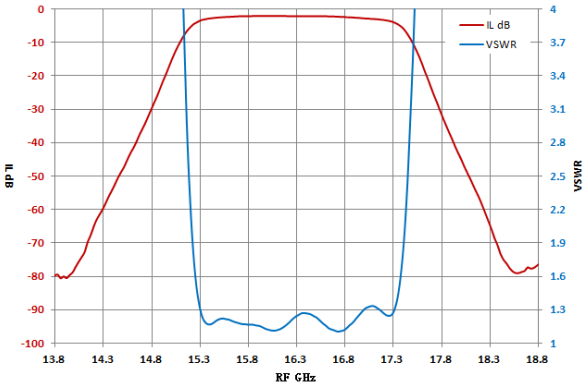


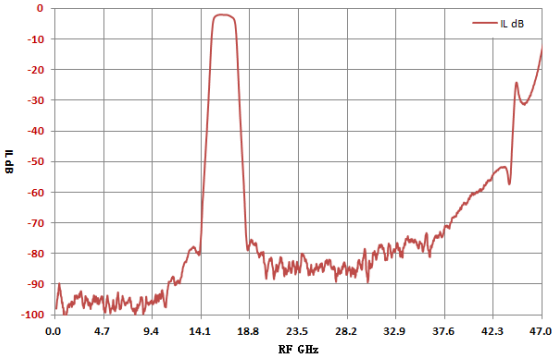
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



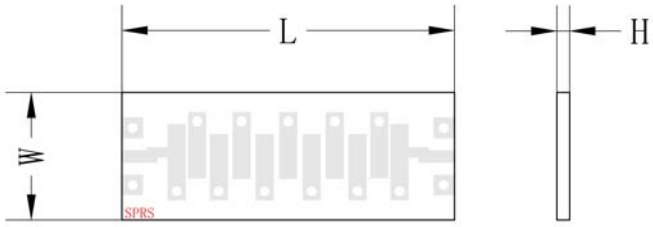
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	16.6	GHz
工作带宽	15.5-17.6	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-14.2GHz	dBc
带外抑制	40@19.0-41.0GHz	dBc

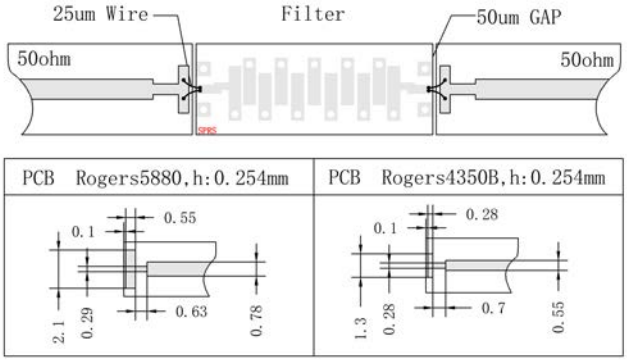
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



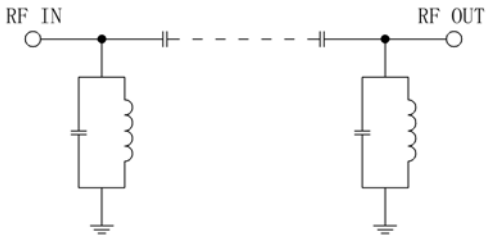
推荐装配图



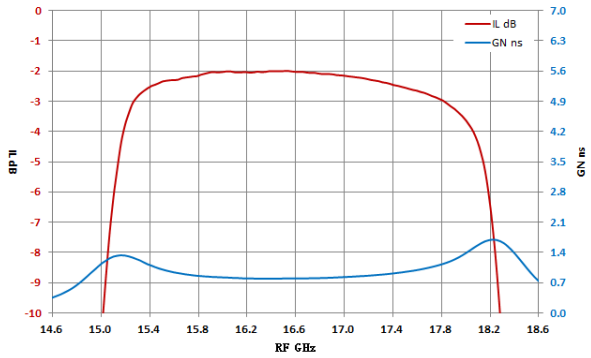
注意事项

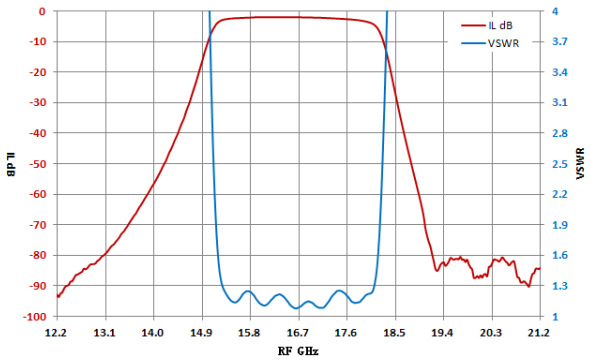
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

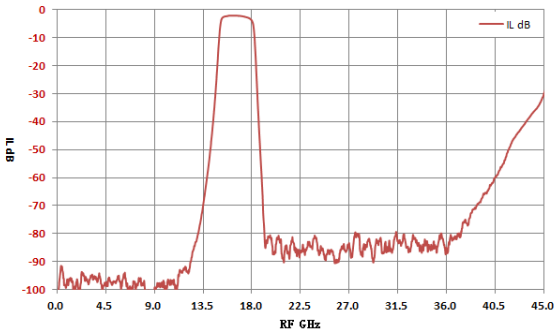
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

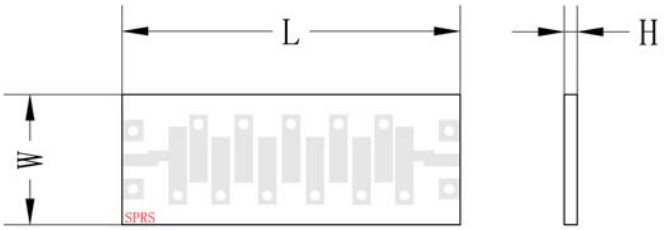
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	15.8	GHz
工作带宽	15.6-16.0	GHz
中心损耗	3.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.6	ns
带外抑制	50@DC-14.7GHz	dBc
带外抑制	50@16.9-36.0GHz	dBc

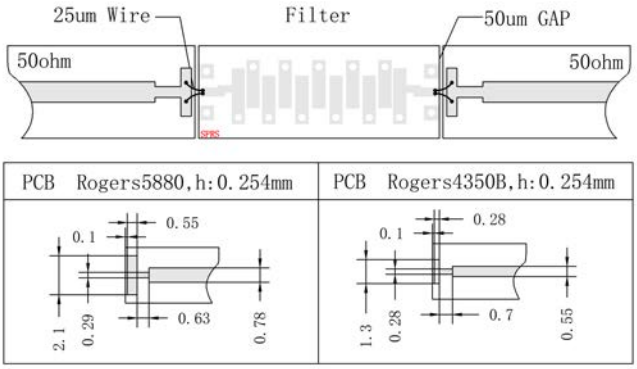
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

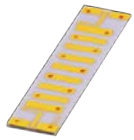
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

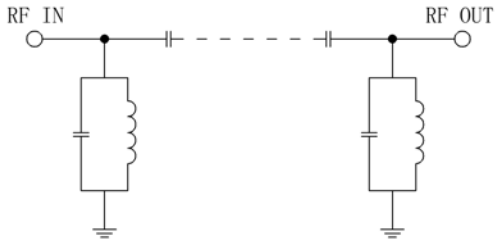
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

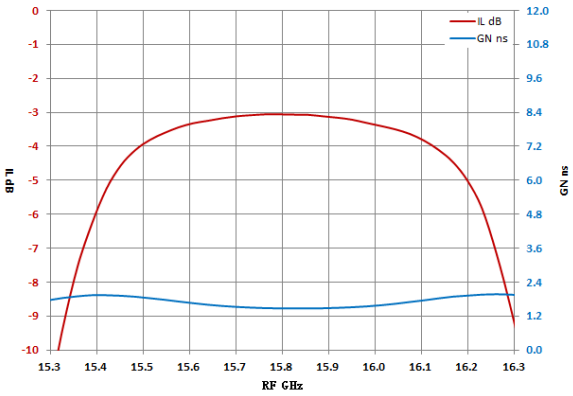
参考图

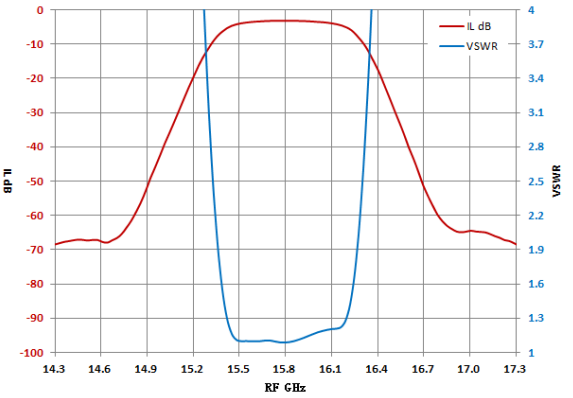


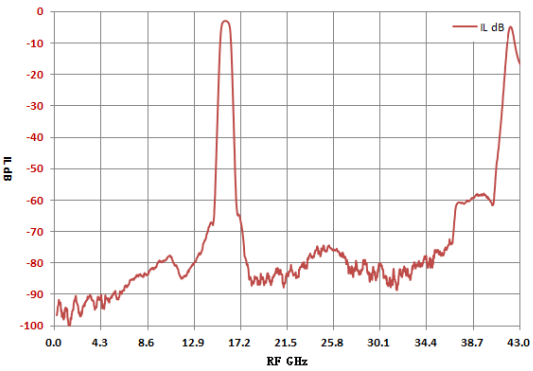
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

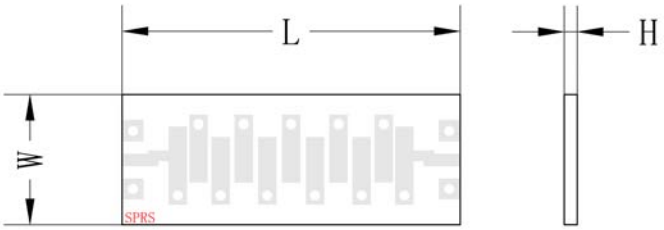
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	16.25	GHz
工作带宽	15.7-16.8	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-14.1GHz	dBc
带外抑制	40@18.4-35.0GHz	dBc

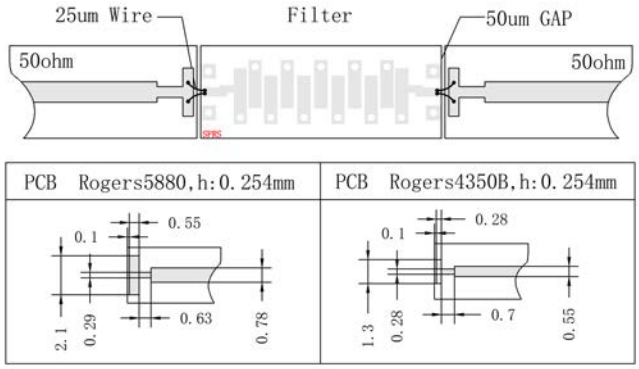
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：7.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

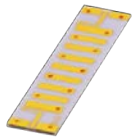
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

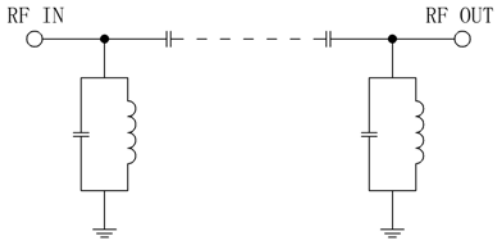
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

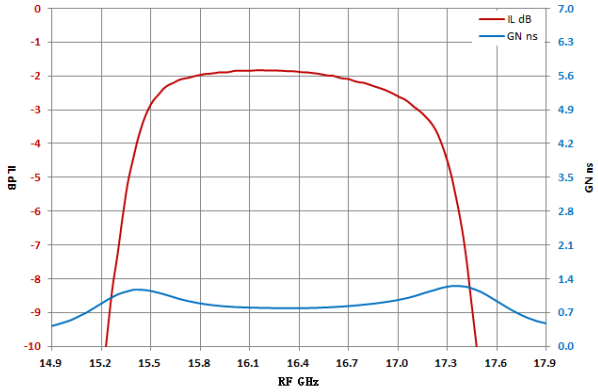
参考图

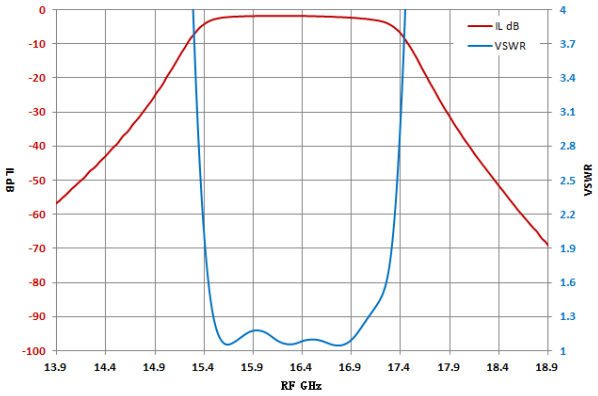


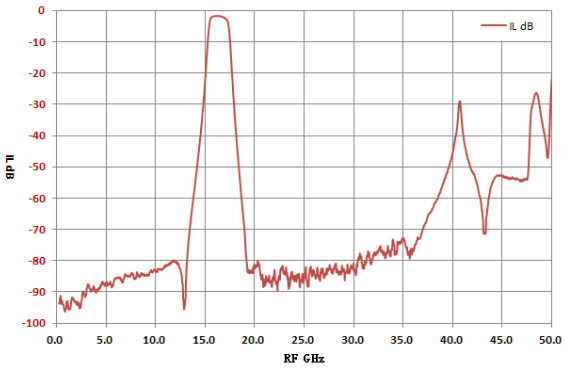
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



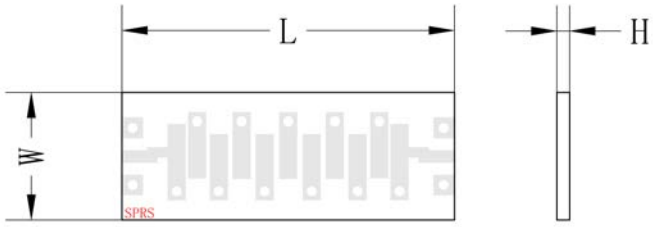
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	16.9	GHz
工作带宽	15.8-18.0	GHz
中心损耗	2.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-14.2GHz	dBc
带外抑制	40@19.8-41.0GHz	dBc

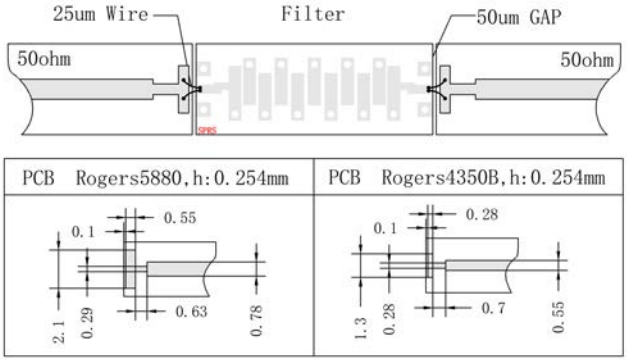
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



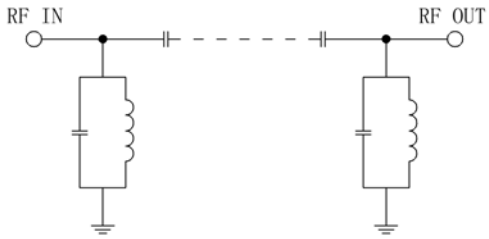
推荐装配图



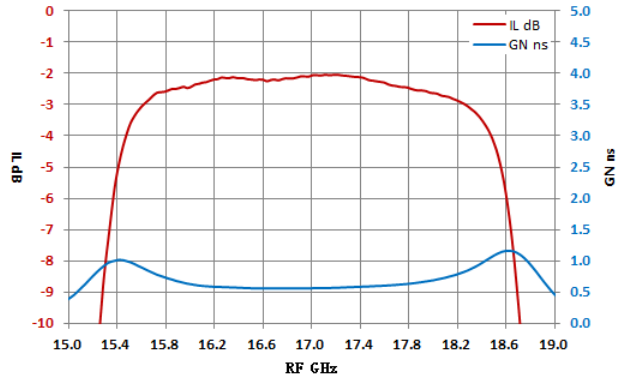
注意事项

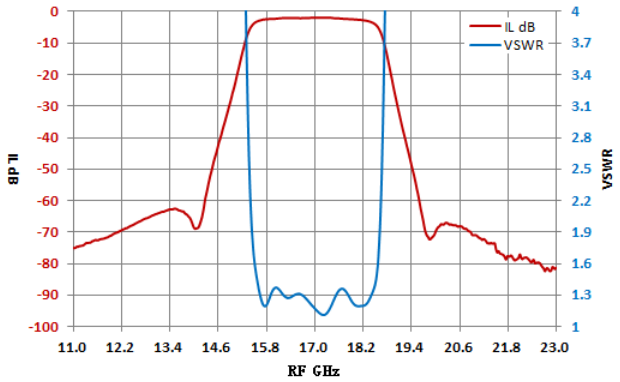
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

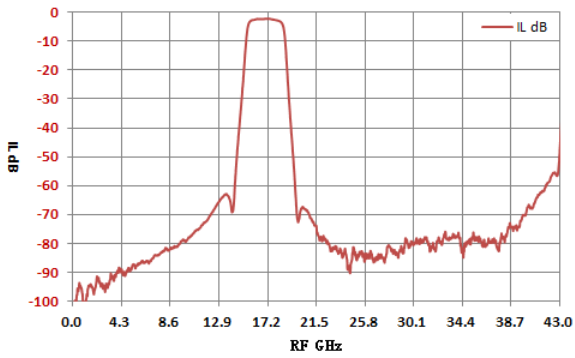
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

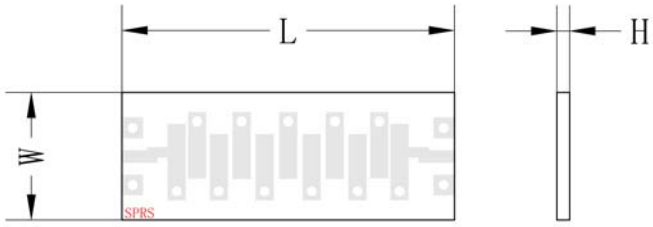
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	18.7	GHz
工作带宽	15.8-21.6	GHz
中心损耗	1.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-12.4GHz	dBc
带外抑制	40@23.8-40.0GHz	dBc

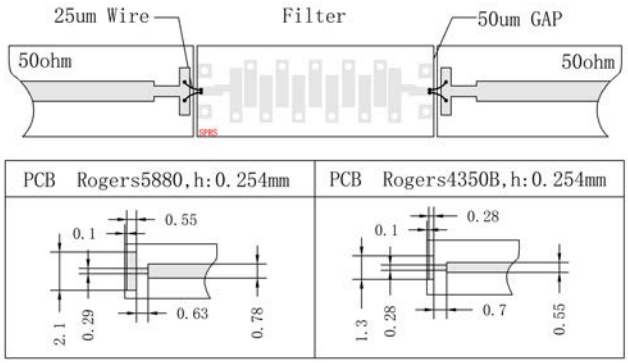
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



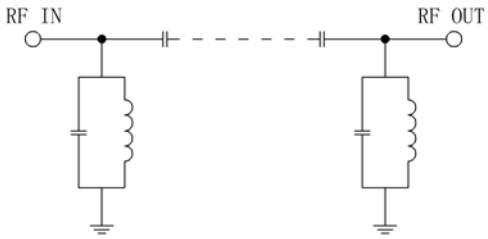
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.87mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

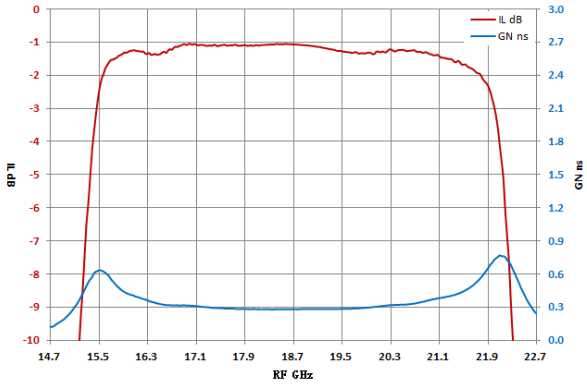
参考实物图

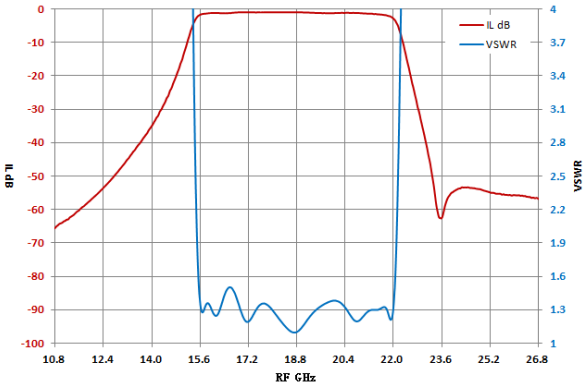


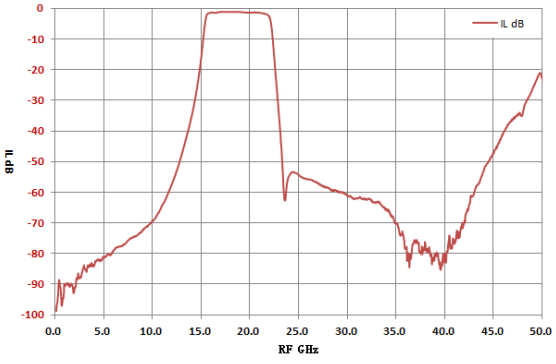
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



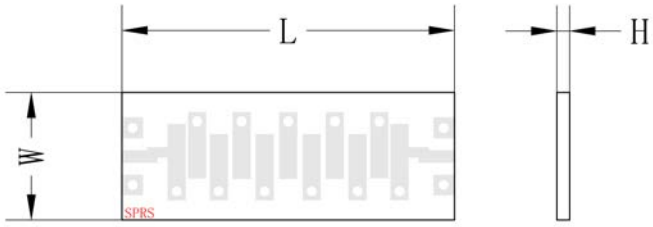
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	18.8	GHz
工作带宽	15.9-21.7	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-13.0GHz	dBc
带外抑制	40@23.6-43.0GHz	dBc

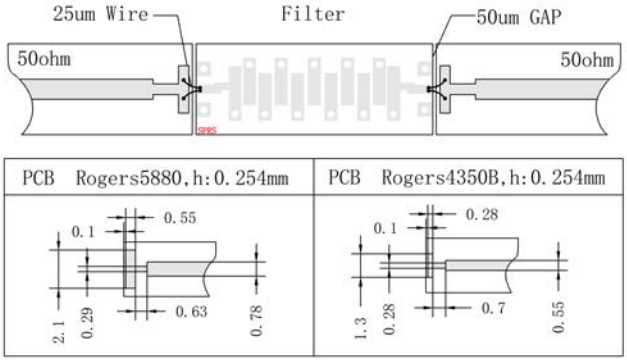
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



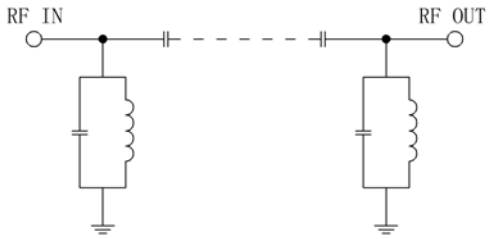
推荐装配图



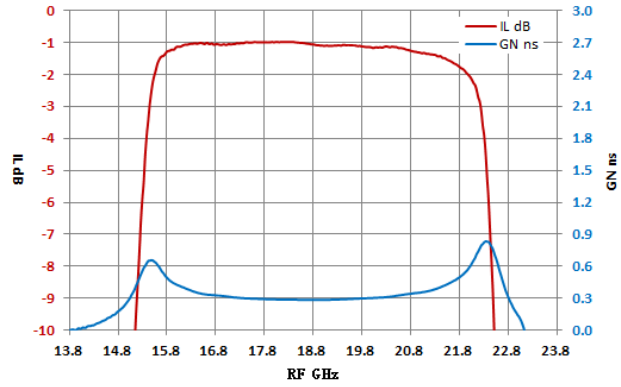
注意事项

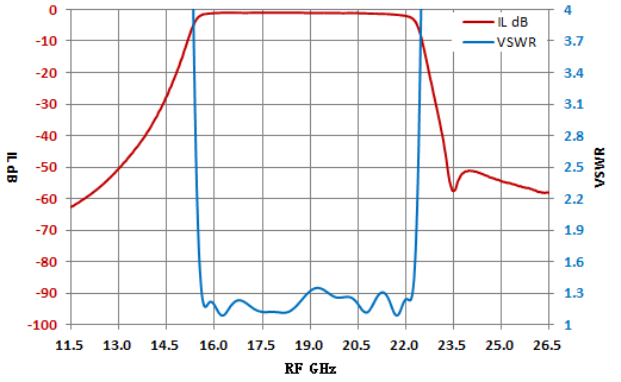
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

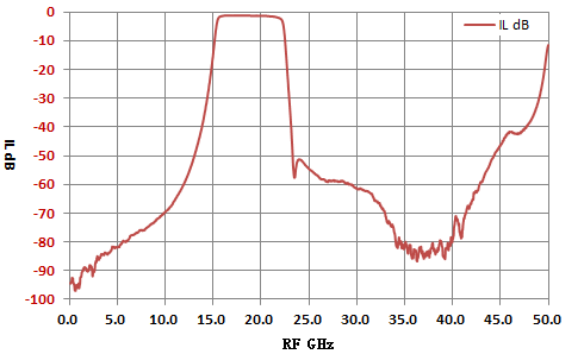
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



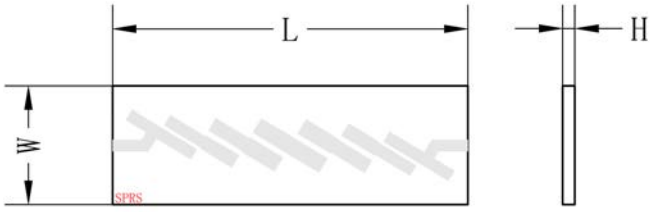
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	16.0	GHz
工作带宽	0	GHz
中心损耗	7.4	dB
带内波动	0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0	ns
带外抑制	40@DC-15.4GHz	dBc
带外抑制	40@16.6-23.0GHz	dBc

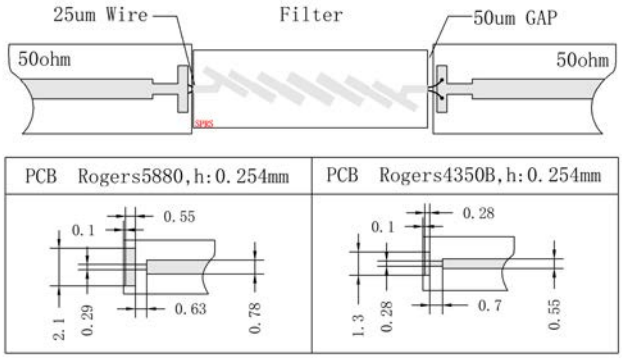
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



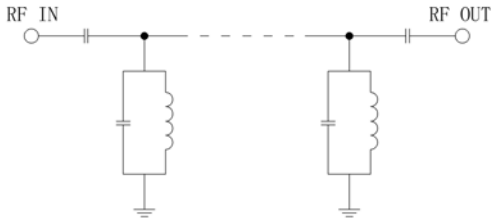
推荐装配图



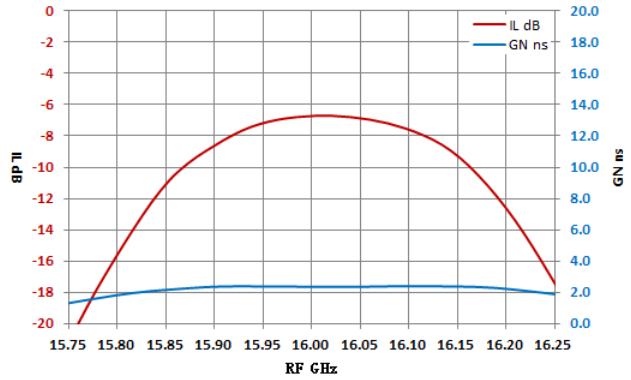
注意事项

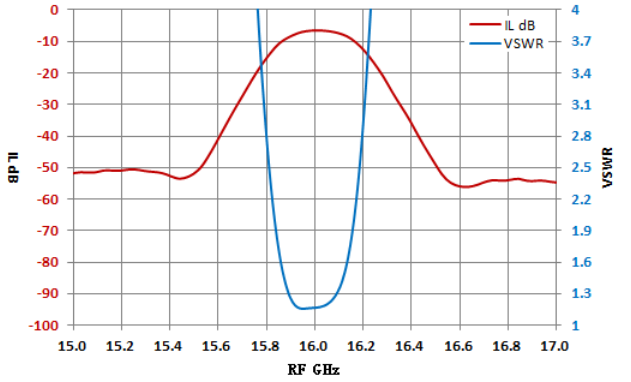
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

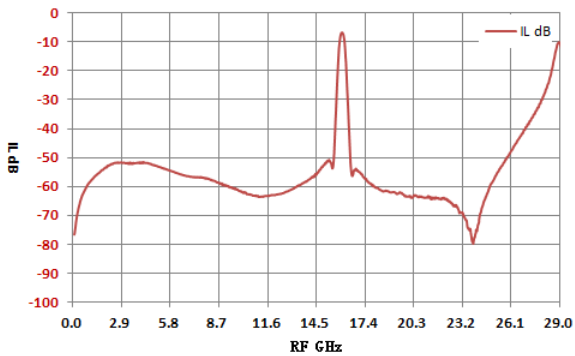
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



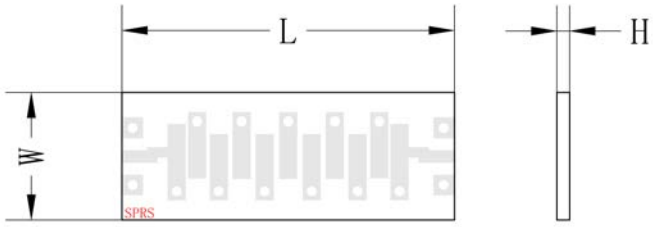
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	17.1	GHz
工作带宽	16.0-18.1	GHz
中心损耗	2.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-14.6GHz	dBc
带外抑制	40@19.6-37.0GHz	dBc

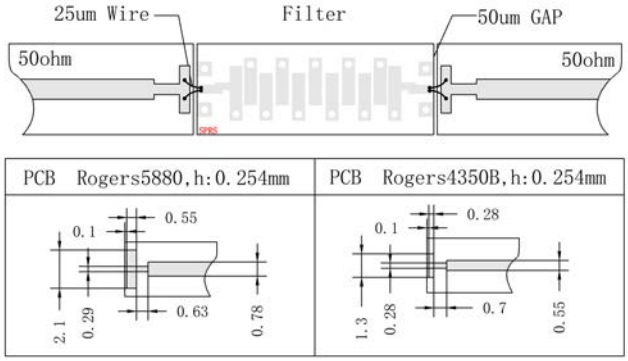
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



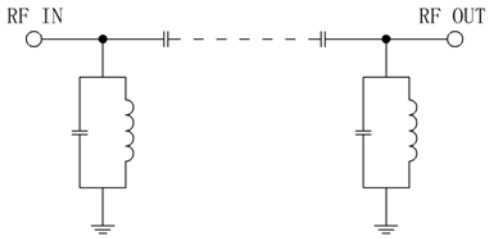
推荐装配图



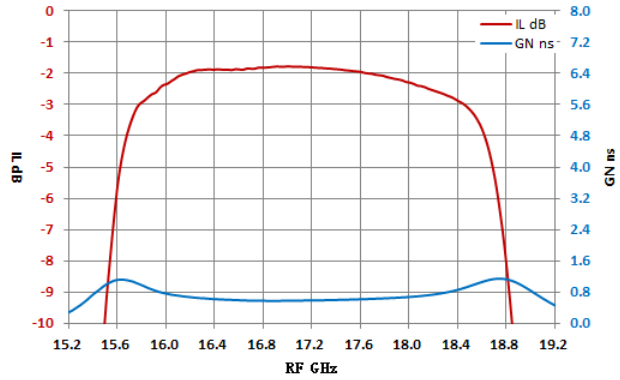
注意事项

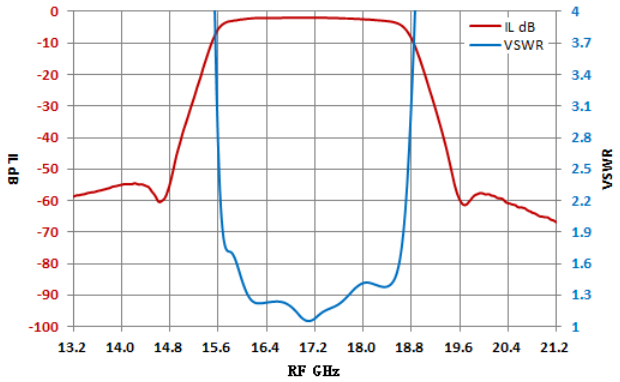
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

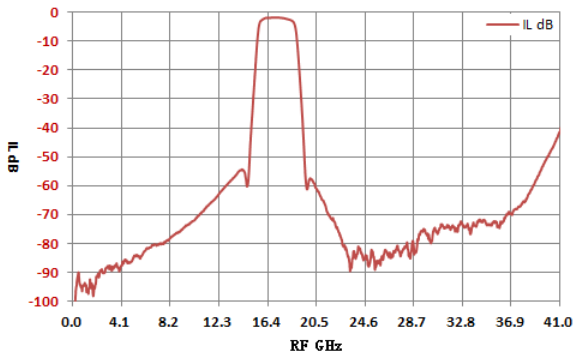
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



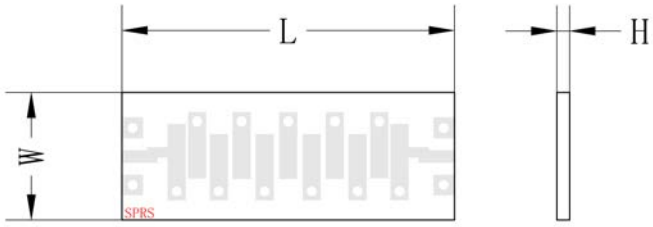
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	18.3	GHz
工作带宽	16.0-20.6	GHz
中心损耗	2.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-14.1GHz	dBc
带外抑制	40@22.9-40.0GHz	dBc

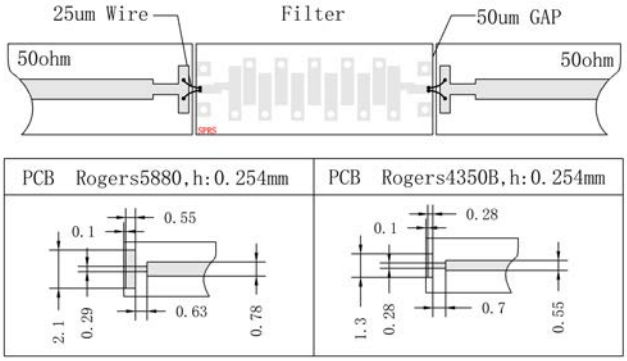
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



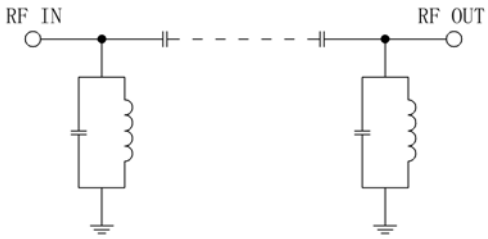
推荐装配图



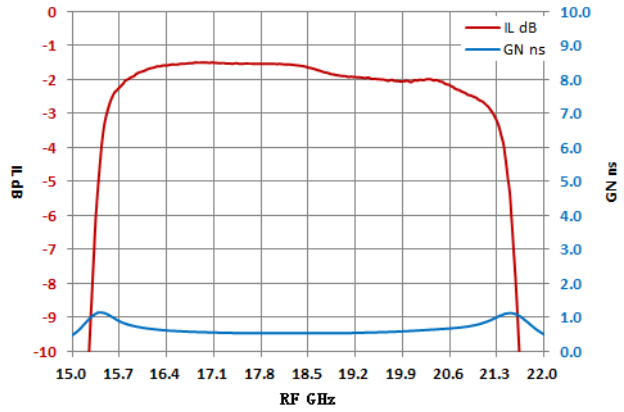
注意事项

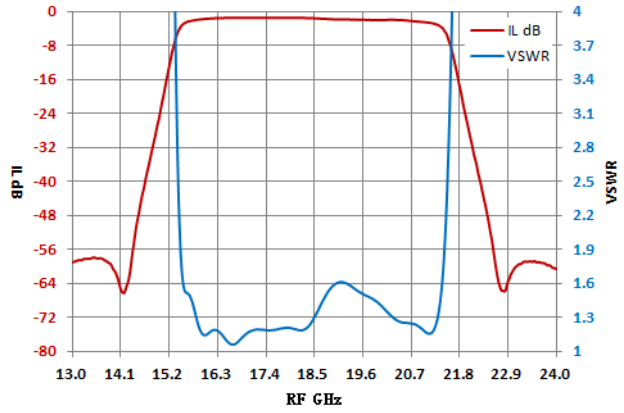
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

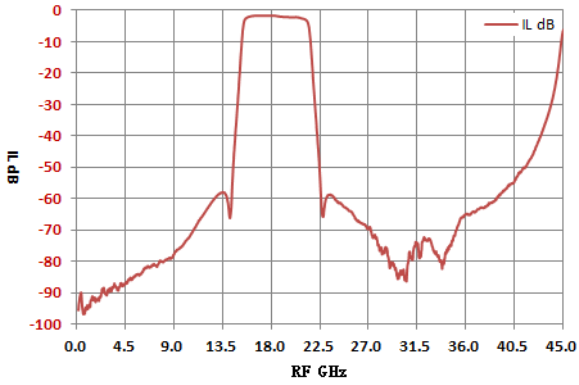
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

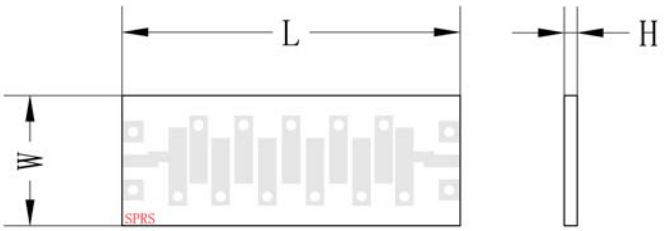
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	19.3	GHz
工作带宽	16.0-22.6	GHz
中心损耗	1.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-13.4GHz	dBc
带外抑制	40@23.5-45.0GHz	dBc

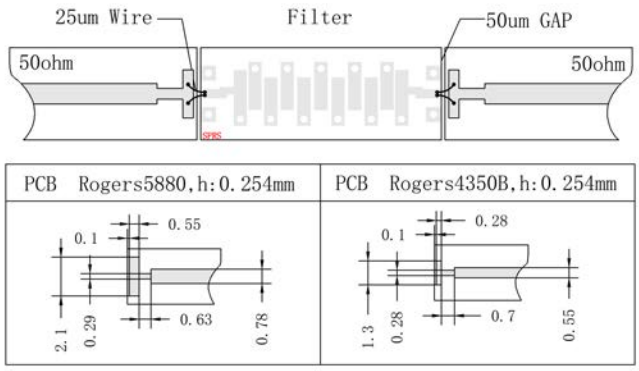
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;

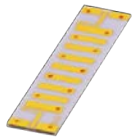
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

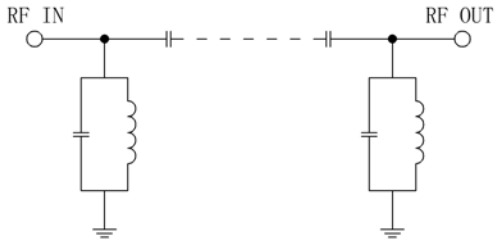
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

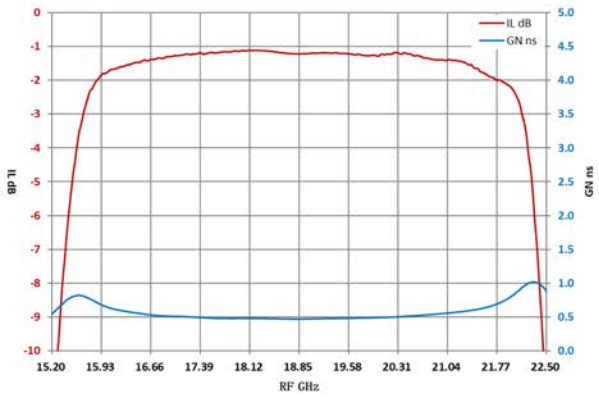
参考图

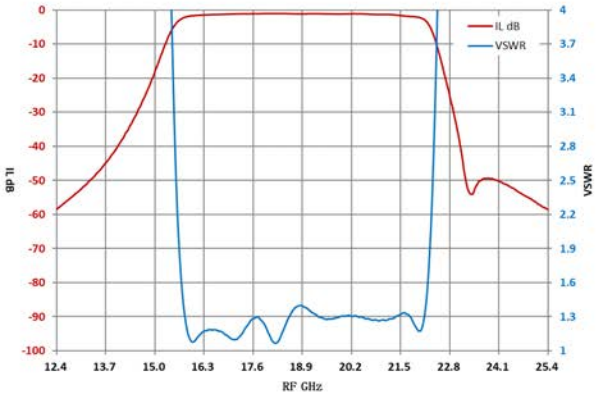


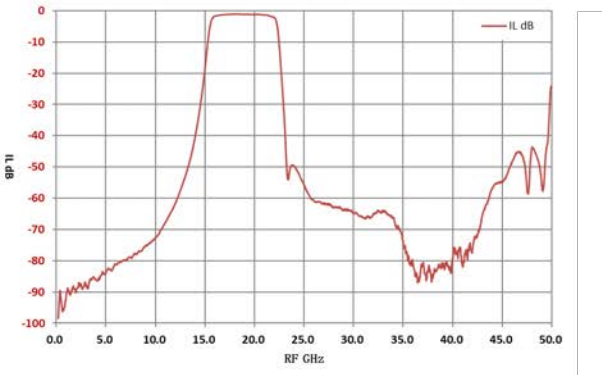
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



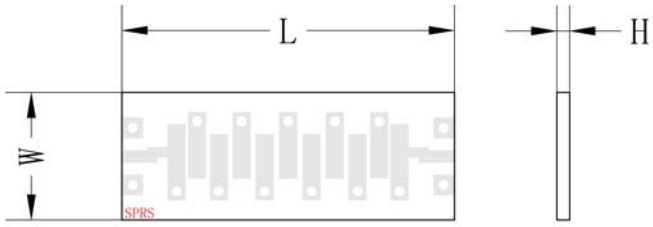
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	19.1	GHz
工作带宽	16.0-22.2	GHz
中心损耗	1.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-12.8GHz	dBc
带外抑制	40@24.3-45.0GHz	dBc

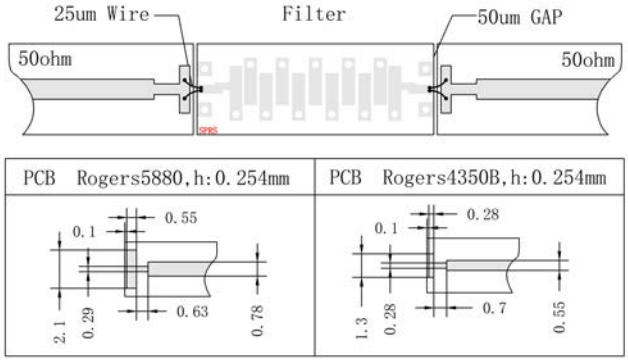
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



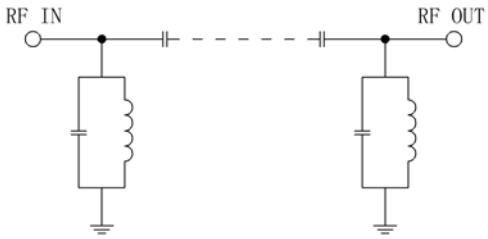
推荐装配图



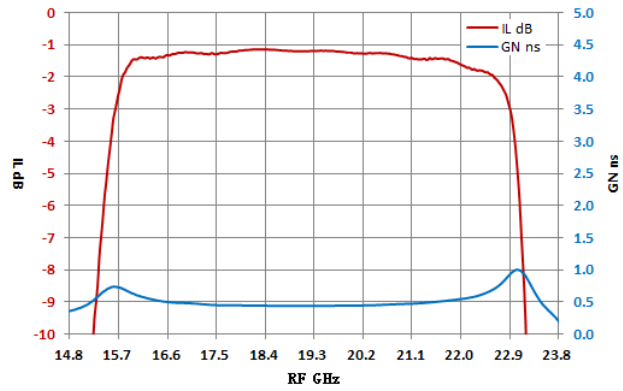
注意事项

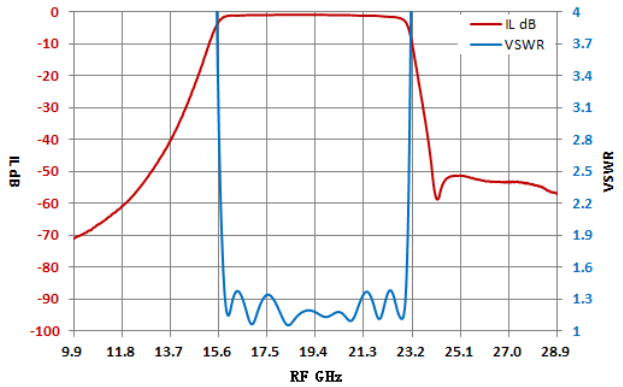
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

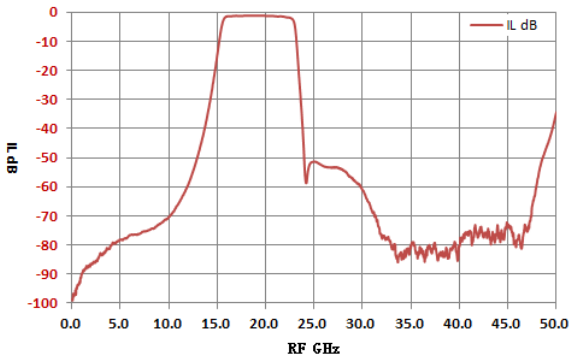
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

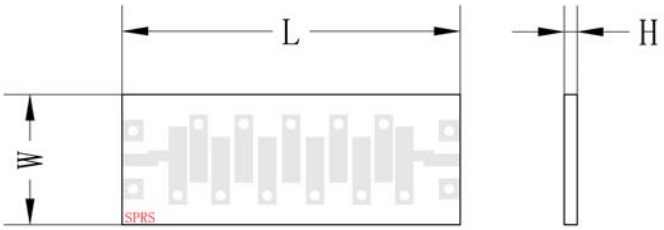
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	19.5	GHz
工作带宽	16.0-23.0	GHz
中心损耗	1.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-14.2GHz	dBc
带外抑制	40@26.6-45.0GHz	dBc

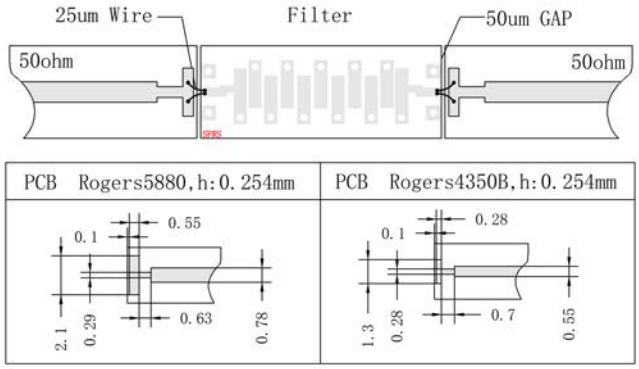
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

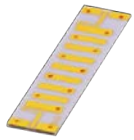
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

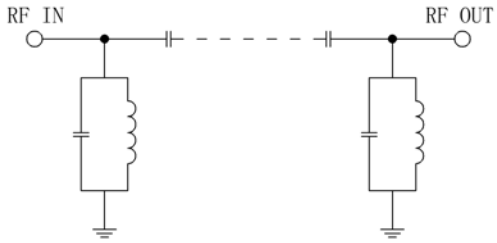
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

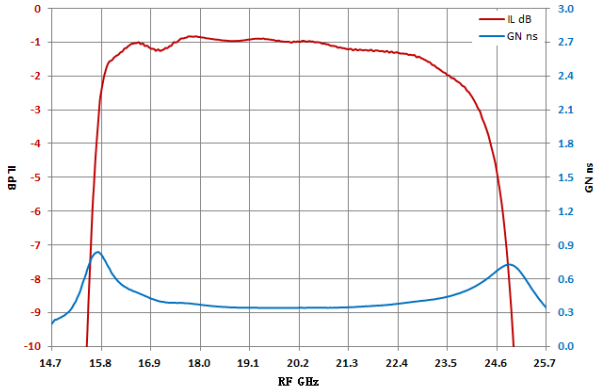
参考图

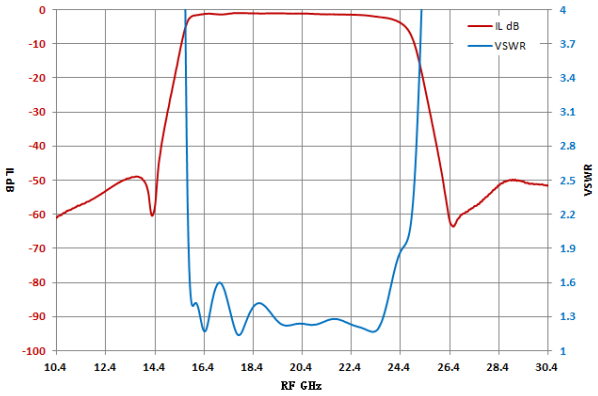


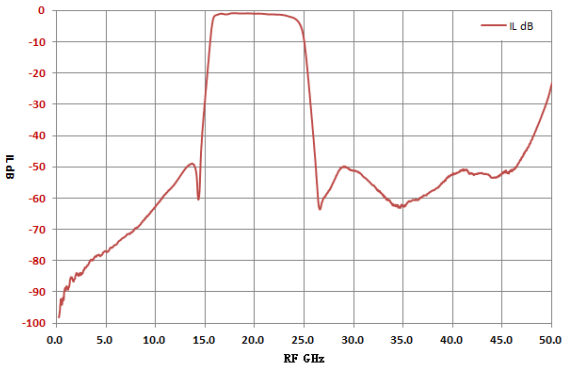
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

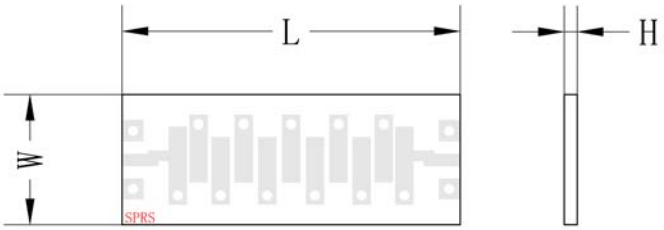
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	16.1	GHz
工作带宽	16.05-16.15	GHz
中心损耗	5.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-15.2GHz	dBc
带外抑制	40@16.7-40.0GHz	dBc

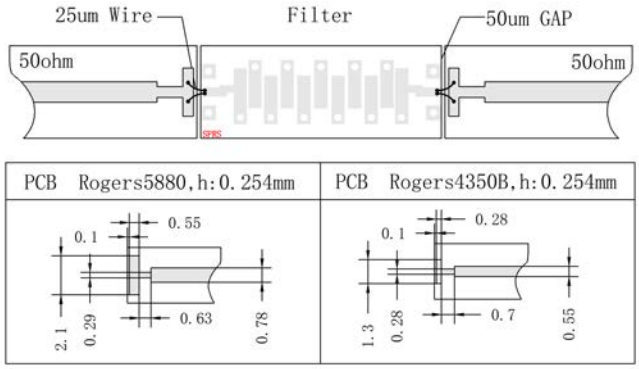
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

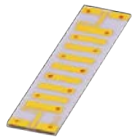
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

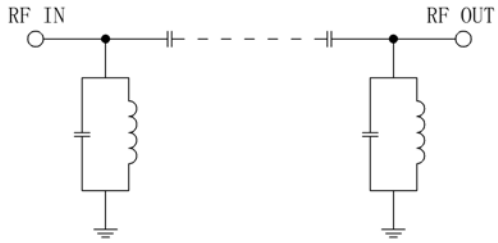
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

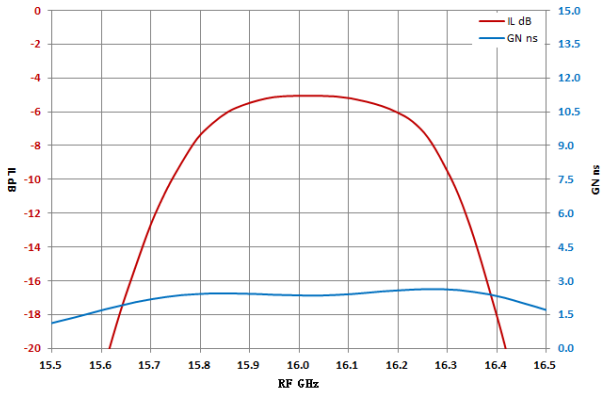
参考图

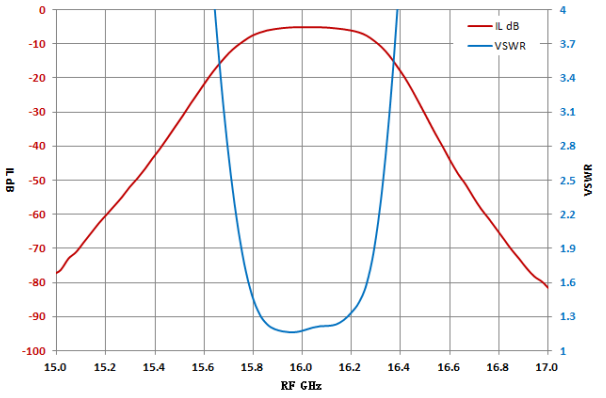


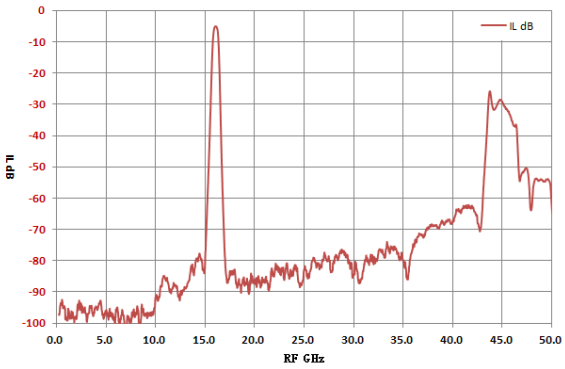
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

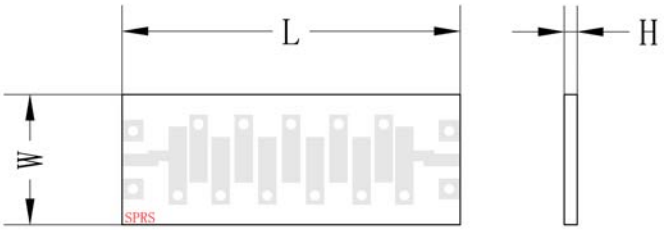
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	16.9	GHz
工作带宽	16.1-17.7	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.8	ns
带外抑制	50@DC-15.0GHz	dBc
带外抑制	50@18.9-45.0GHz	dBc

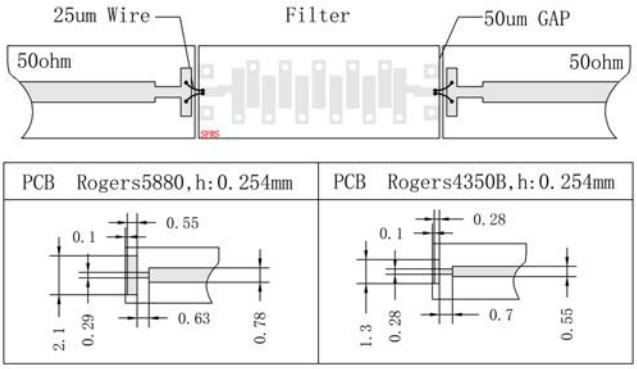
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

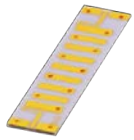
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

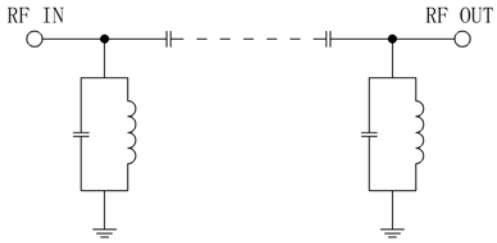
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

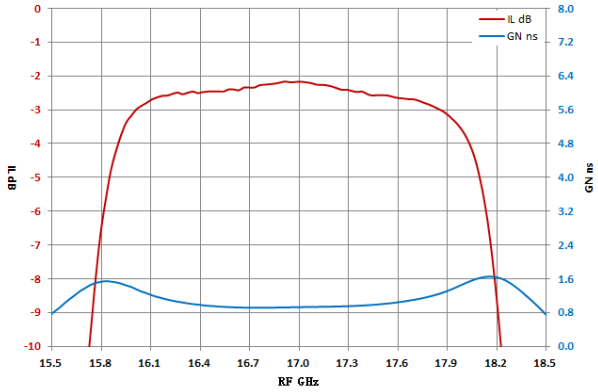
参考图

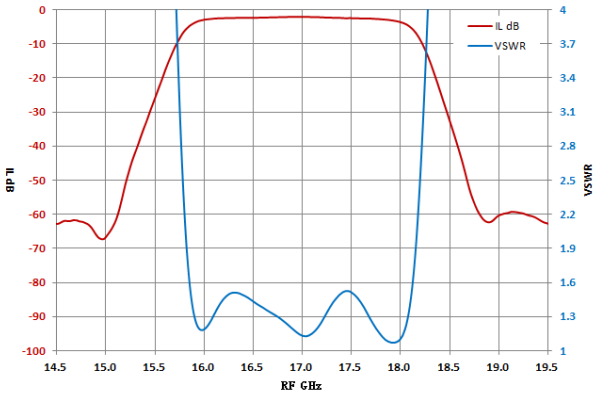


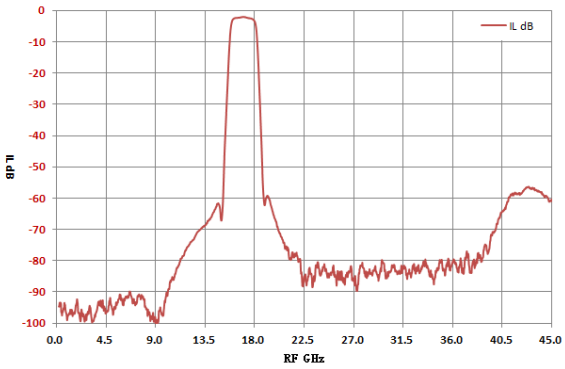
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



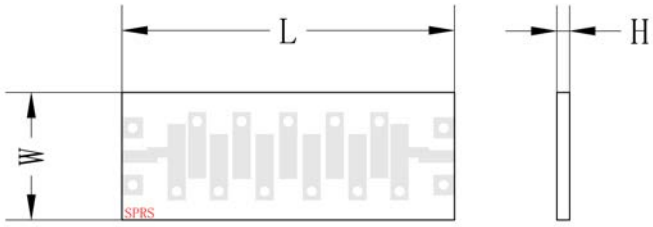
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	17.0	GHz
工作带宽	16.1-17.8	GHz
中心损耗	2.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-15.0GHz	dBc
带外抑制	40@19.0-40.0GHz	dBc

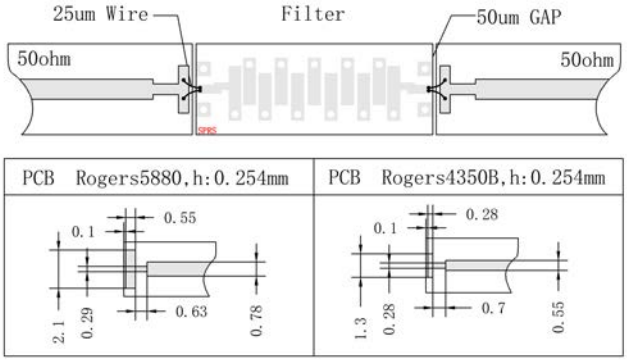
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



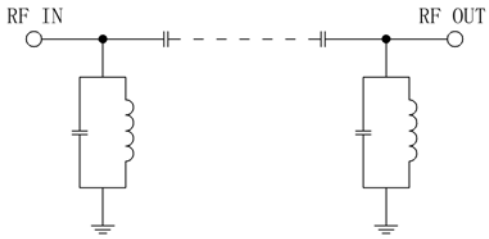
推荐装配图



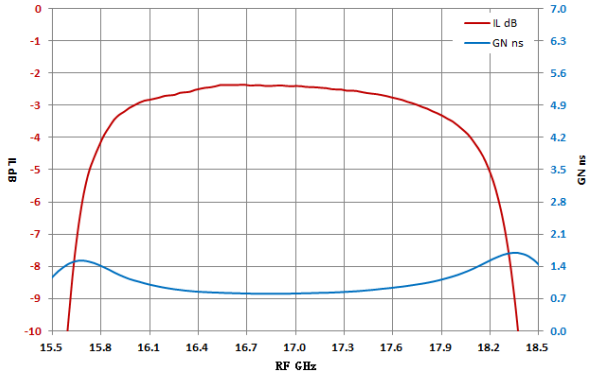
注意事项

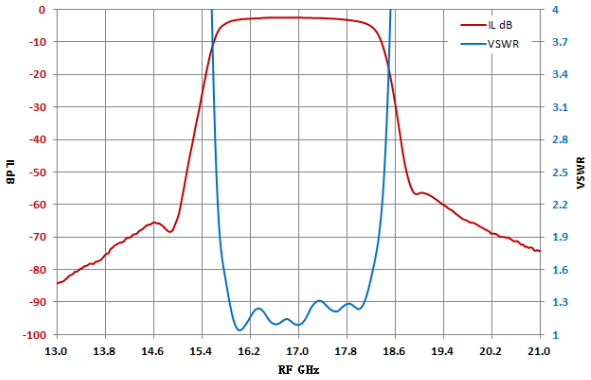
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

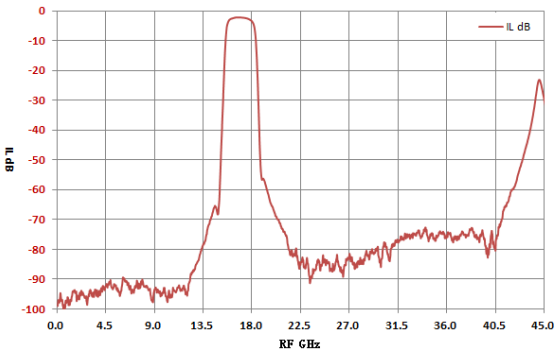
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



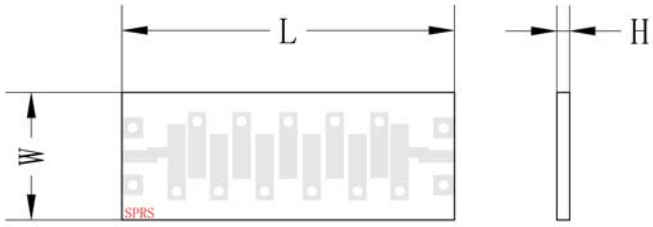
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	16.8	GHz
工作带宽	16.2-17.4	GHz
中心损耗	5.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-14.4GHz	dBc
带外抑制	40@19.2-36.0GHz	dBc

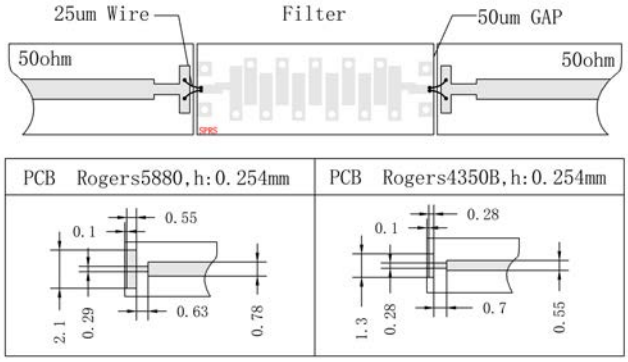
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：10.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



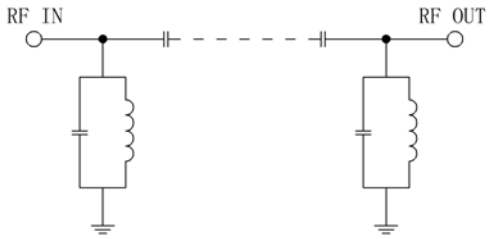
推荐装配图



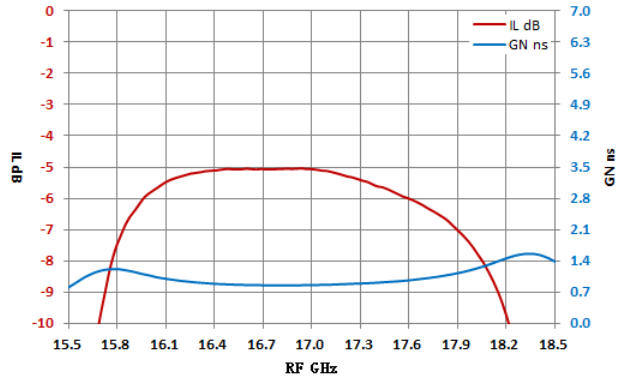
注意事项

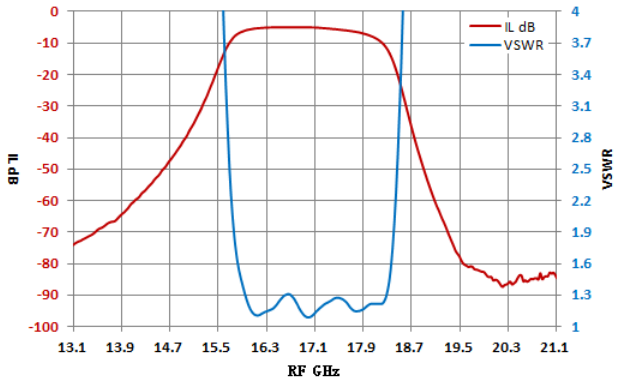
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

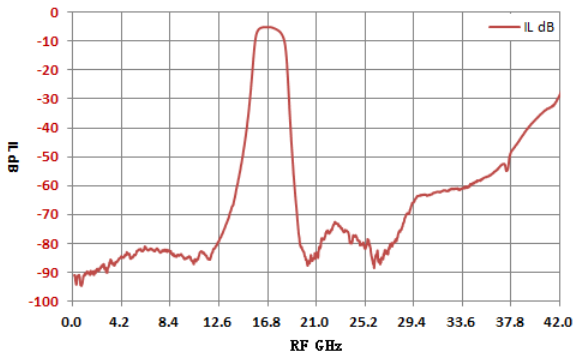
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

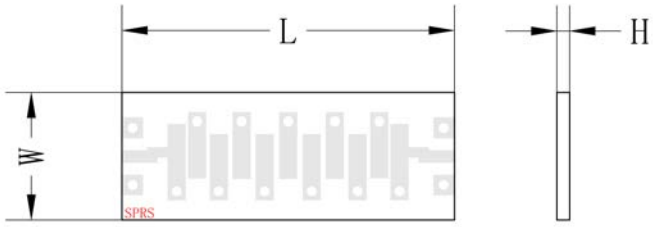
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	19.3	GHz
工作带宽	16.2-22.4	GHz
中心损耗	1.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-13.7GHz	dBc
带外抑制	40@25.0-27.0GHz	dBc

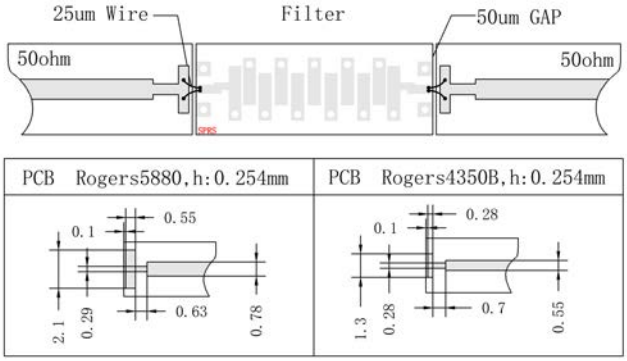
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



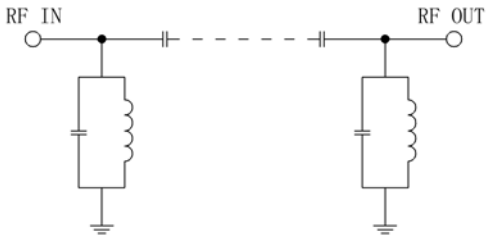
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

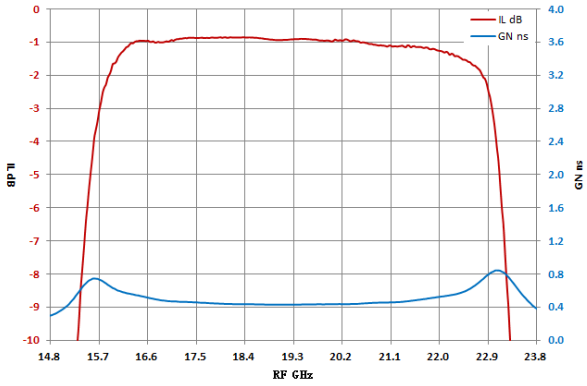
参考实物图

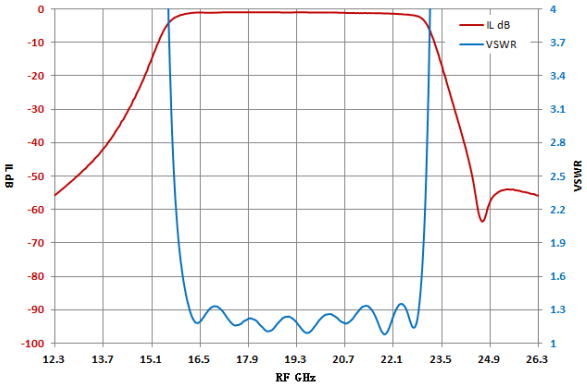


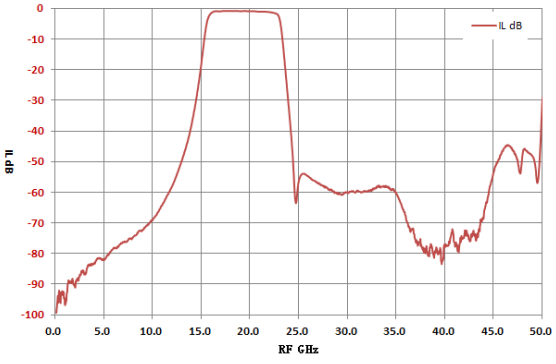
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



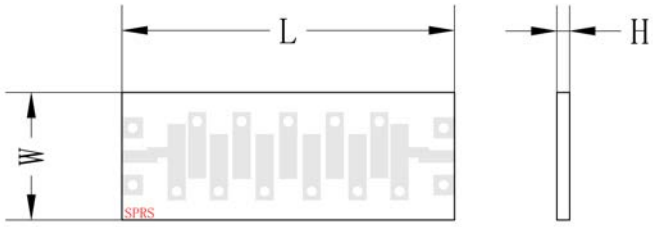
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	16.8	GHz
工作带宽	16.3-17.3	GHz
中心损耗	2.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-14.6GHz	dBc
带外抑制	40@18.5-38.0GHz	dBc

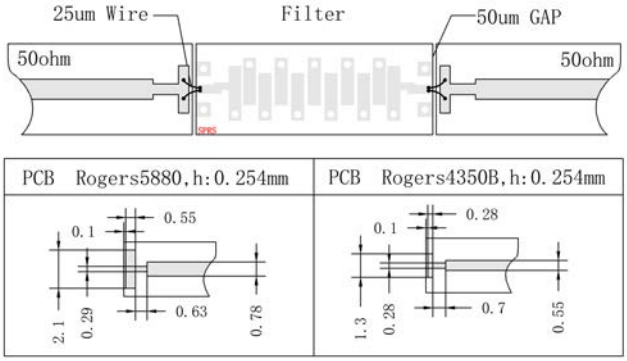
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



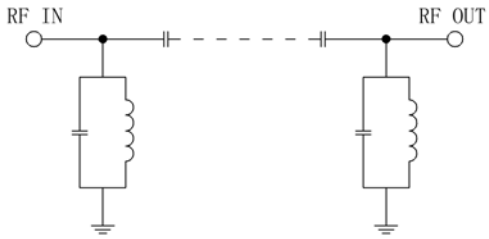
推荐装配图



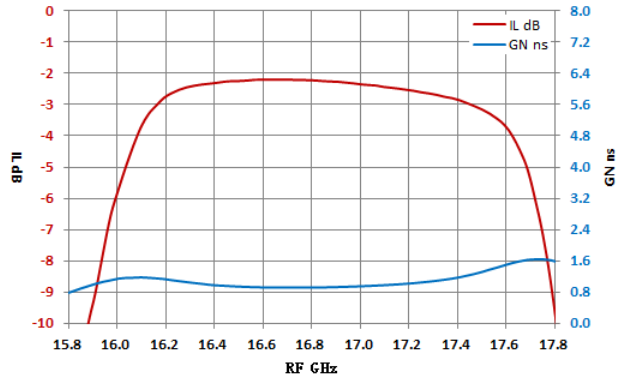
注意事项

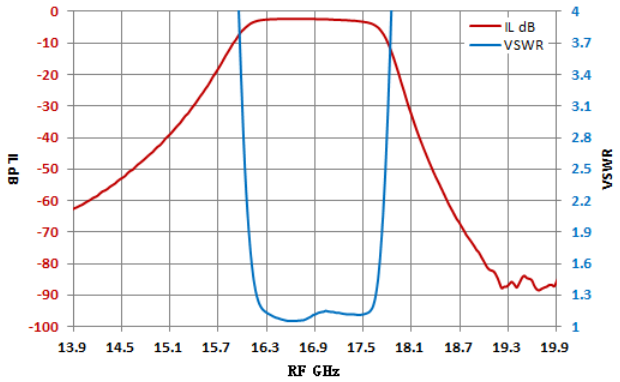
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

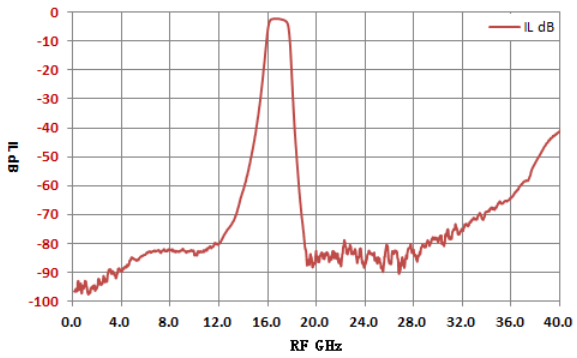
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



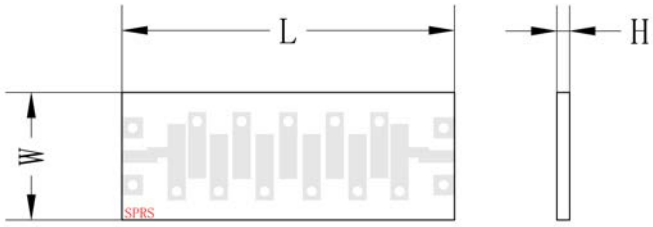
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	17.7	GHz
工作带宽	16.3-19.1	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-14.7GHz	dBc
带外抑制	40@20.5-40.0GHz	dBc

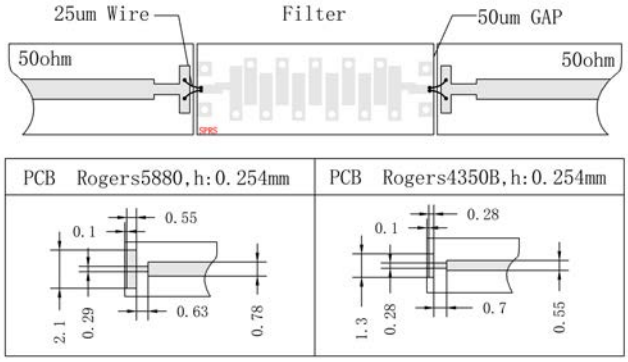
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



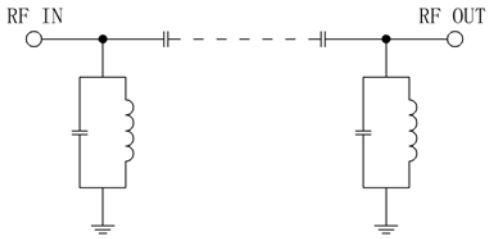
推荐装配图



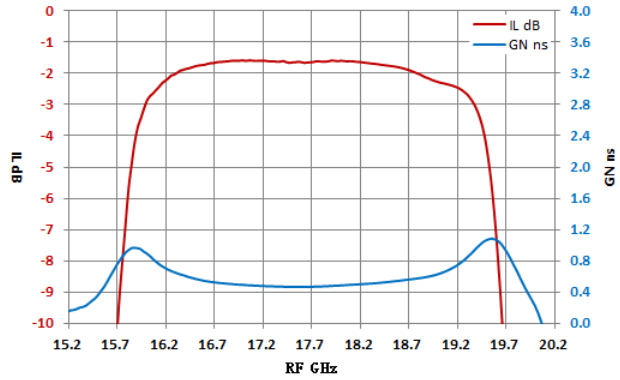
注意事项

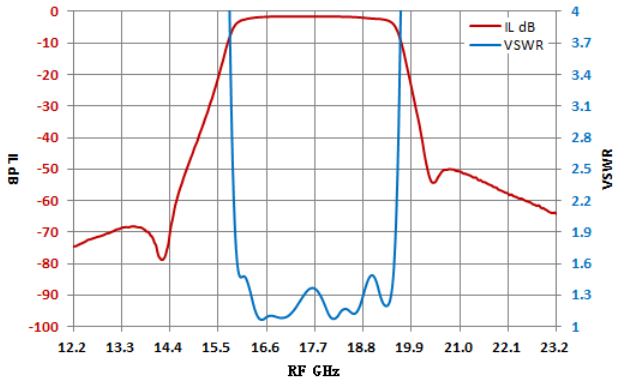
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

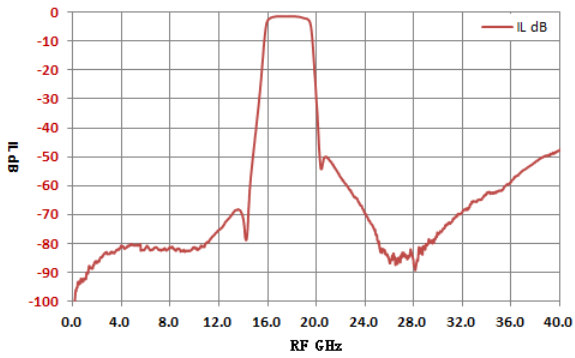
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

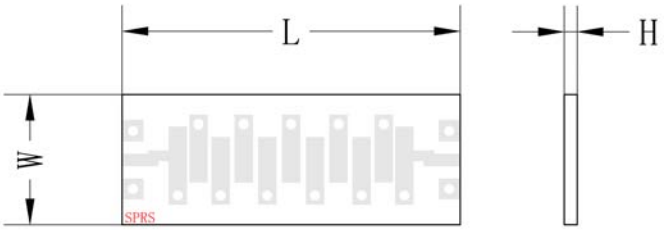
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	20.5	GHz
工作带宽	16.3-24.7	GHz
中心损耗	1.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	50@DC-14.2GHz	dBc
带外抑制	50@27.6-44.0GHz	dBc

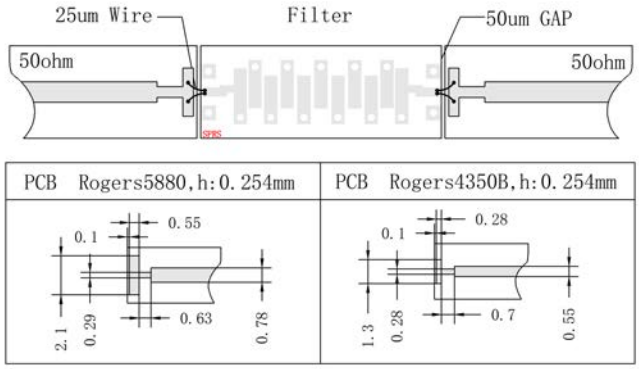
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：6.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

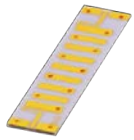
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

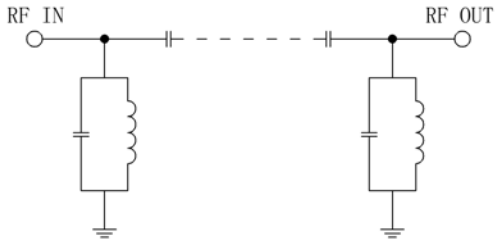
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

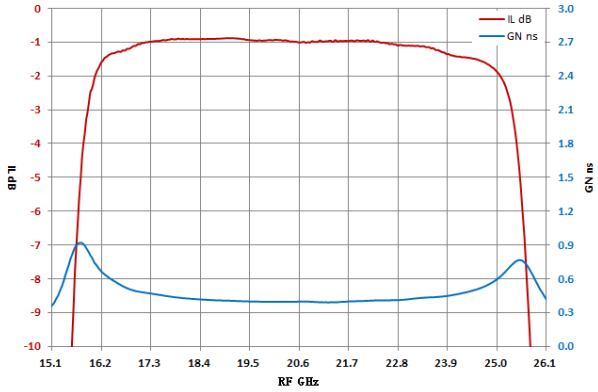
参考图

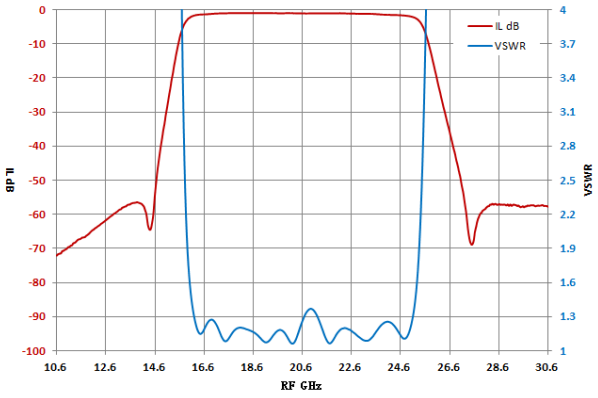


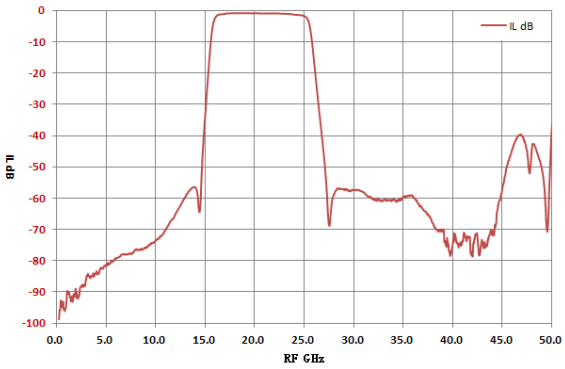
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



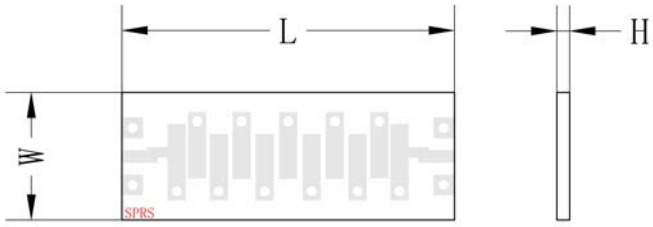
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	17.2	GHz
工作带宽	16.4-18.0	GHz
中心损耗	3.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-15.1GHz	dBc
带外抑制	40@19.5-37.0GHz	dBc

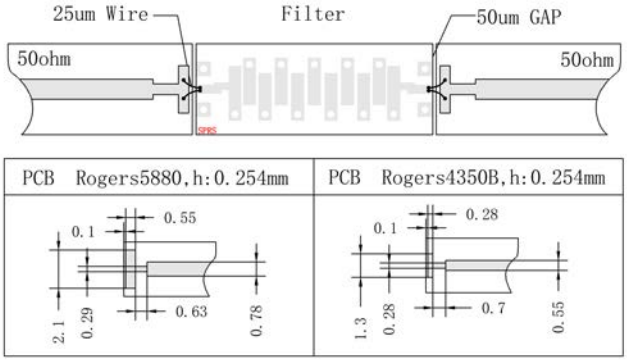
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



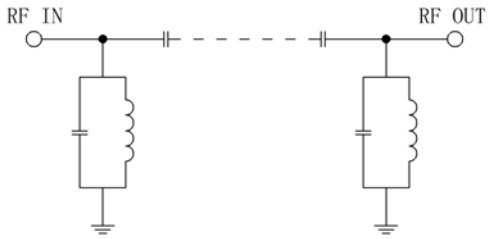
推荐装配图



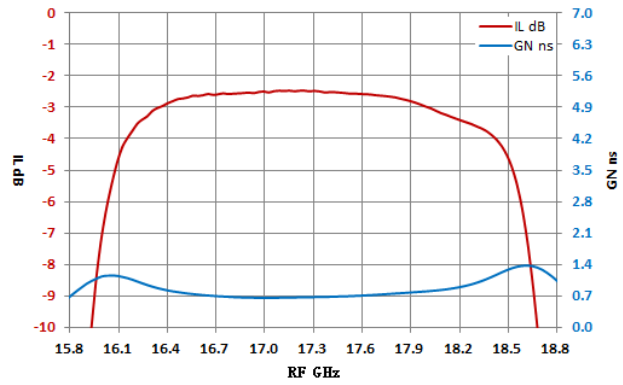
注意事项

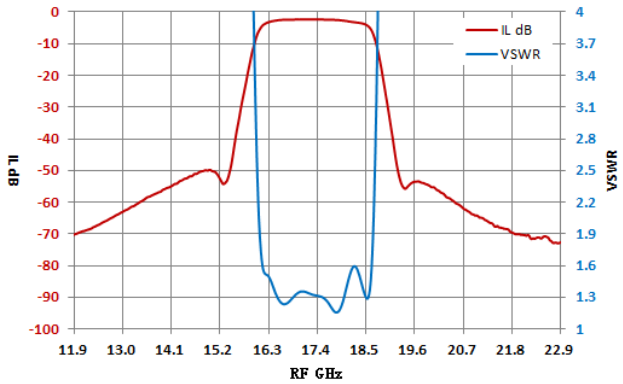
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

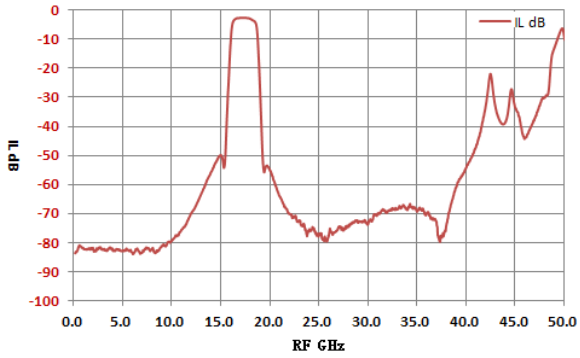
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



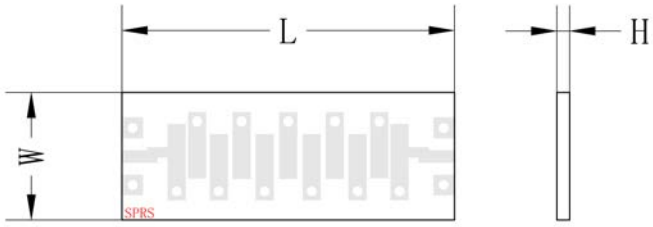
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	20.1	GHz
工作带宽	16.4-23.8	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-14.8GHz	dBc
带外抑制	35@26.0-47.0GHz	dBc

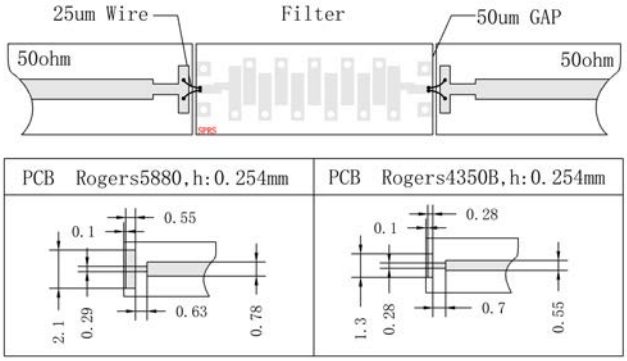
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



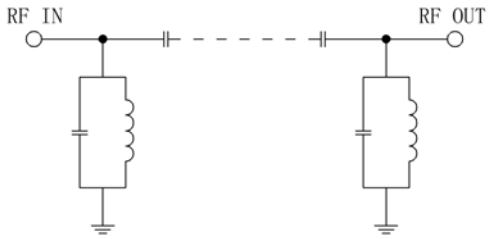
推荐装配图



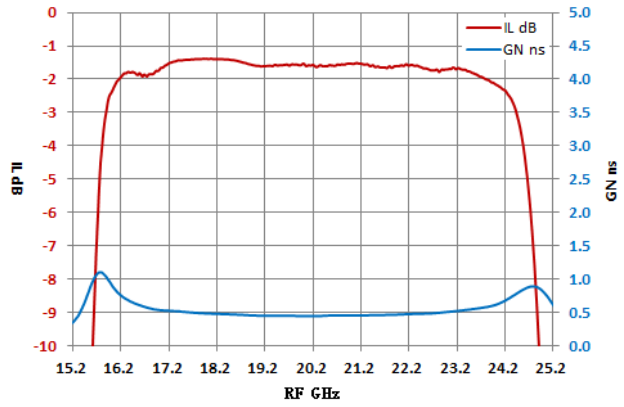
注意事项

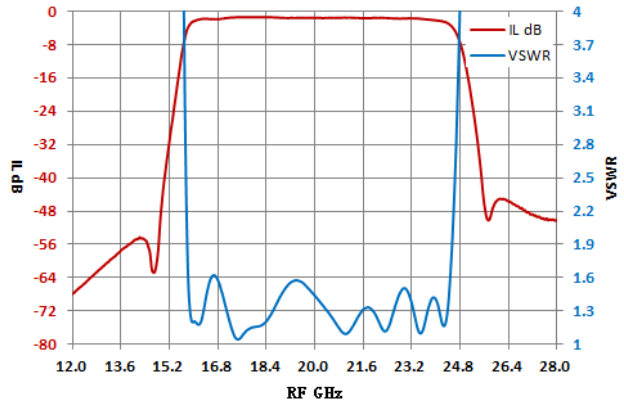
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

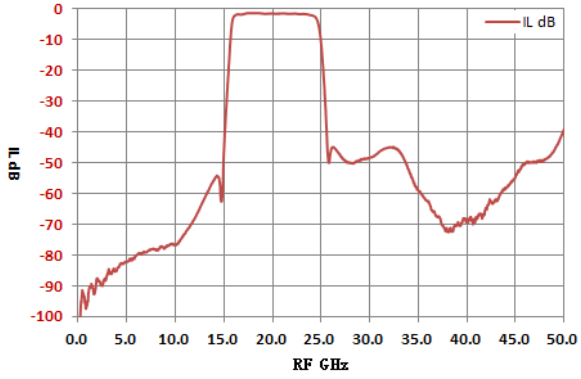
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

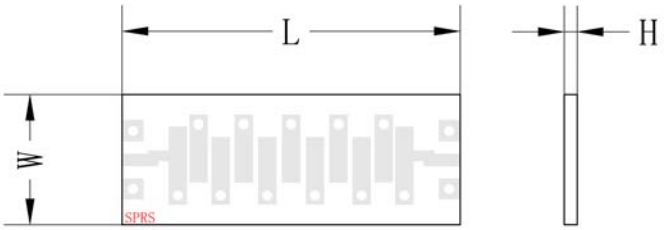
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	17.35	GHz
工作带宽	16.7-18.0	GHz
中心损耗	3.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.8:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-15.4GHz	dBc
带外抑制	40@19.2-44.0GHz	dBc

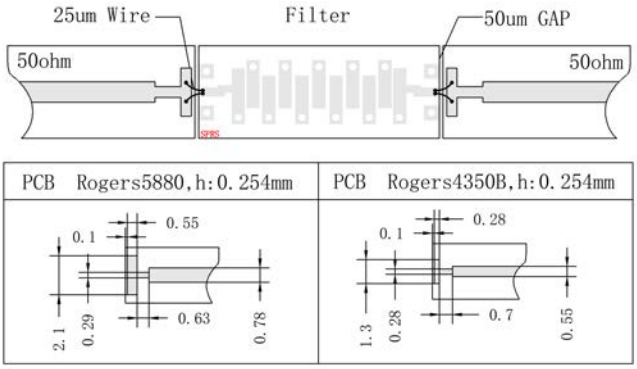
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：9.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

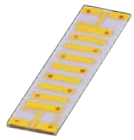
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

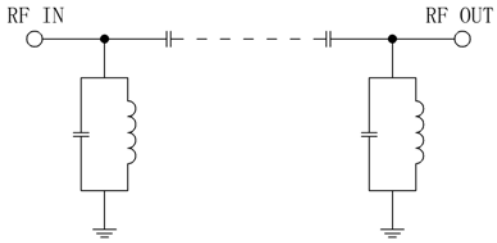
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

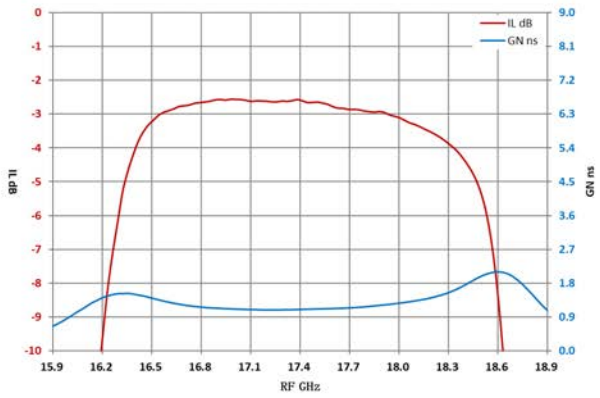
参考图

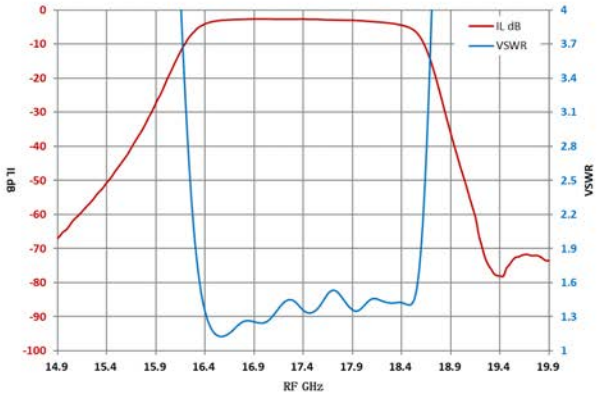


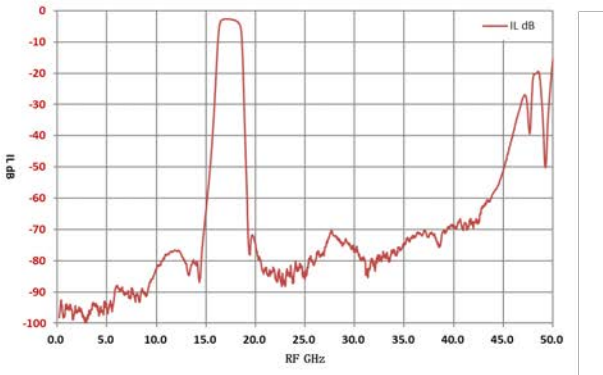
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

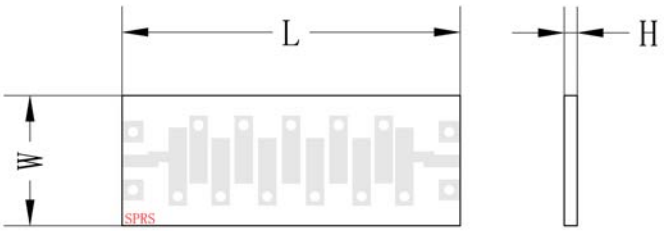
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	20.5	GHz
工作带宽	16.7-24.3	GHz
中心损耗	1.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.8:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	60@DC-14.3GHz	dBc
带外抑制	40@26.9-48.0GHz	dBc

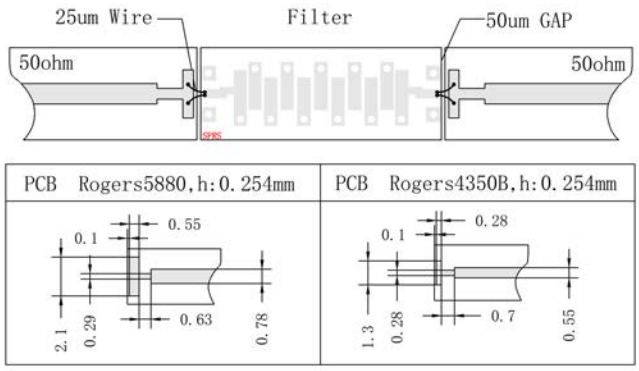
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：9.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

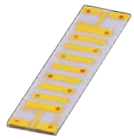
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

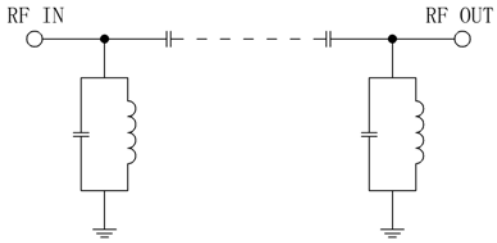
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

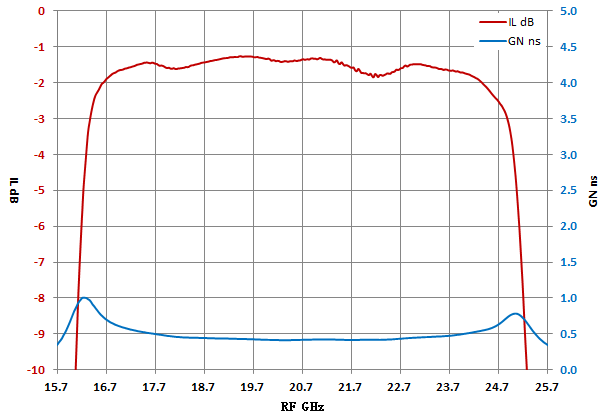
参考图

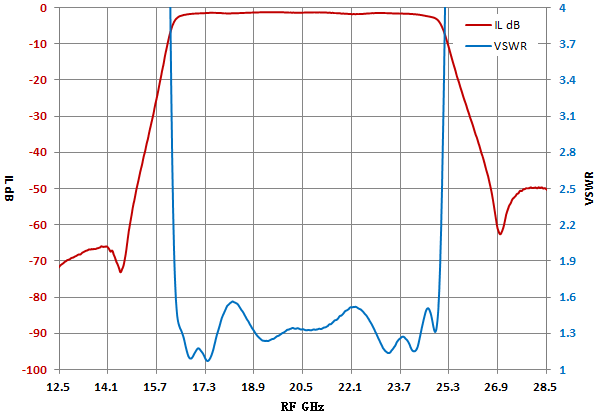


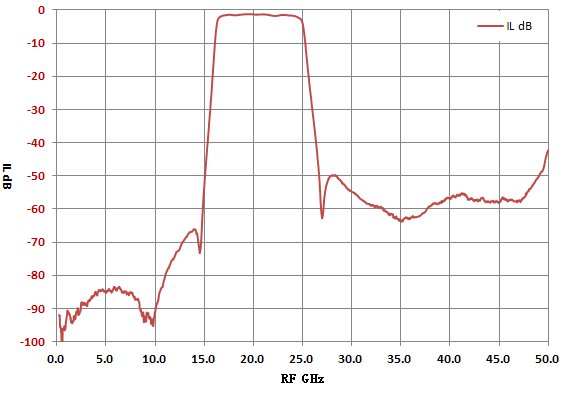
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

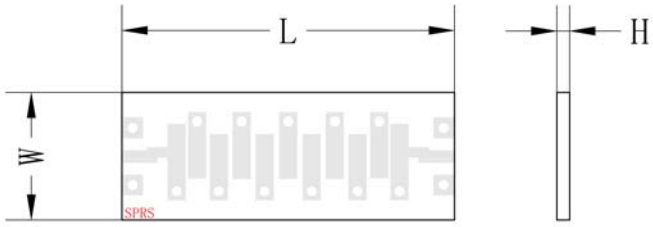
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	21.8	GHz
工作带宽	16.8-26.8	GHz
中心损耗	1.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-12.5GHz	dBc
带外抑制	40@30.5-42.0GHz	dBc

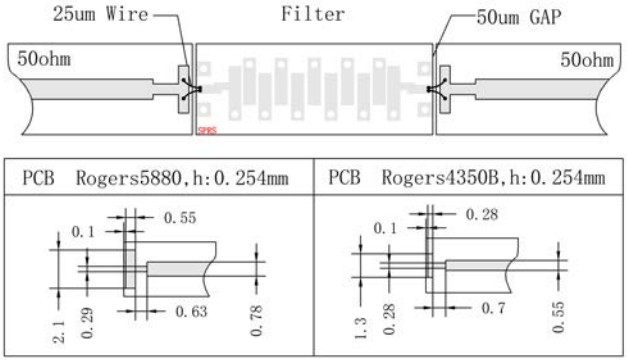
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



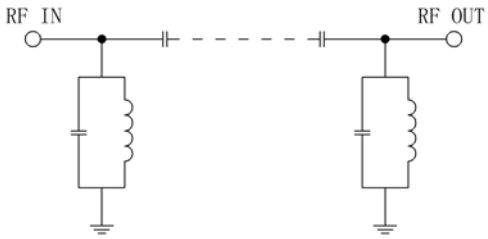
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

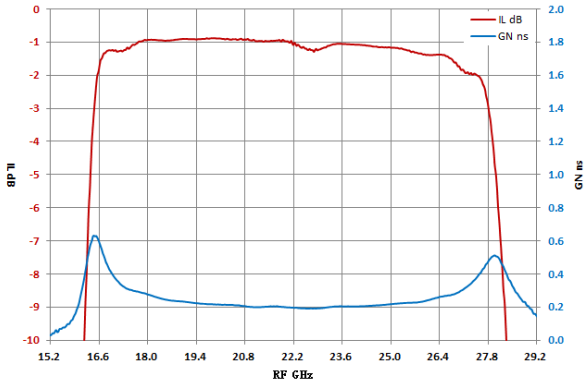
参考实物图

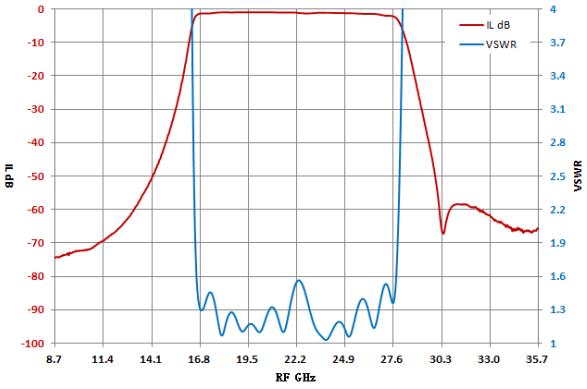


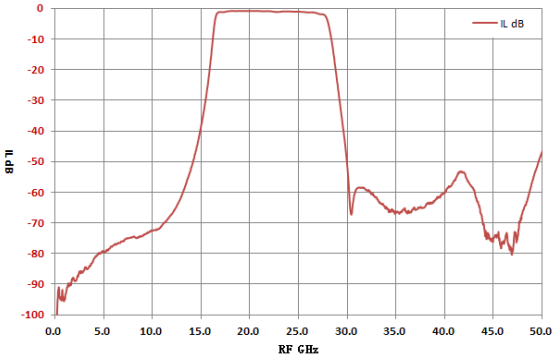
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

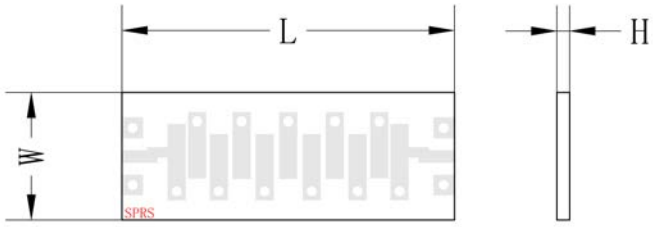
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	20.2	GHz
工作带宽	16.9-23.5	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-14.3GHz	dBc
带外抑制	40@26.3-47.5GHz	dBc

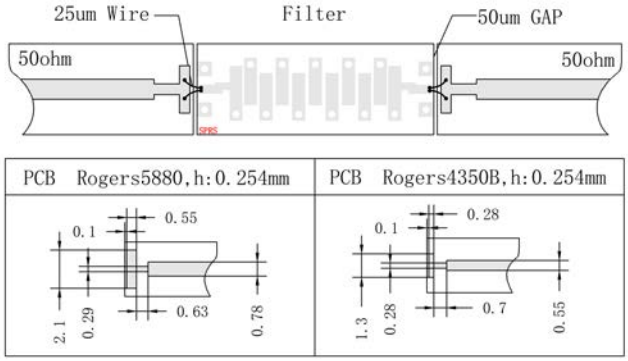
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



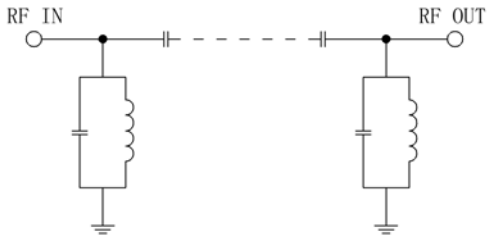
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

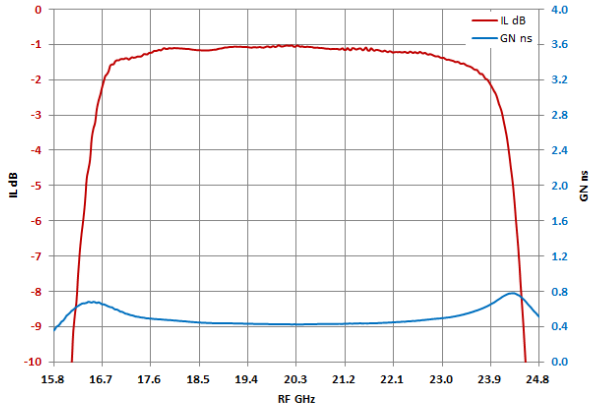
参考实物图

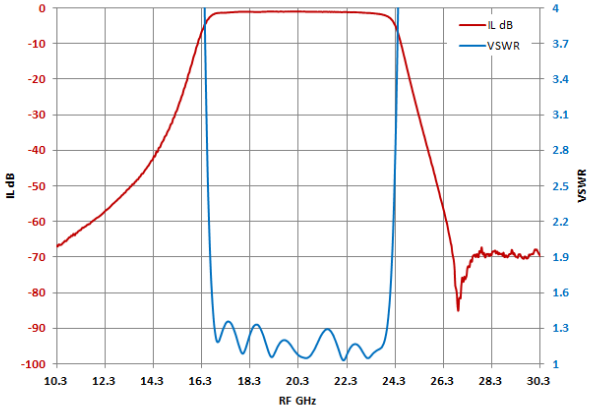


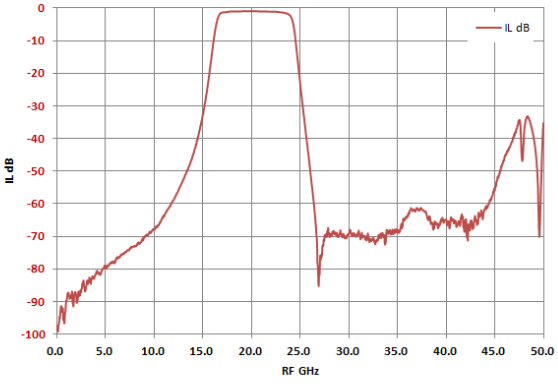
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

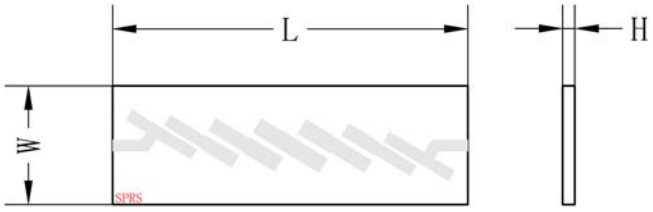
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	17.8	GHz
工作带宽	17.0-18.6	GHz
中心损耗	2.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-15.7GHz	dBc
带外抑制	40@20.3-30.0GHz	dBc

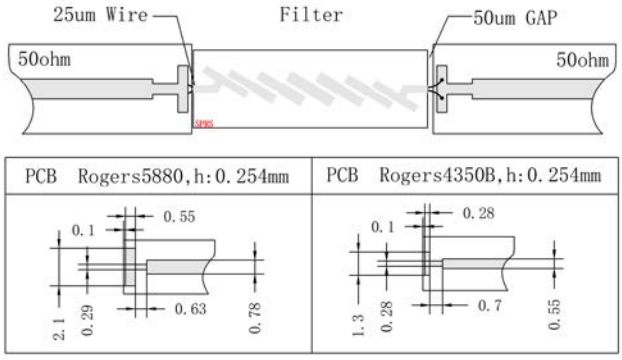
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.5，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



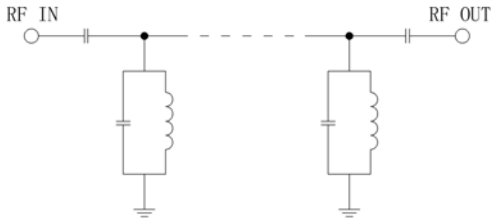
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

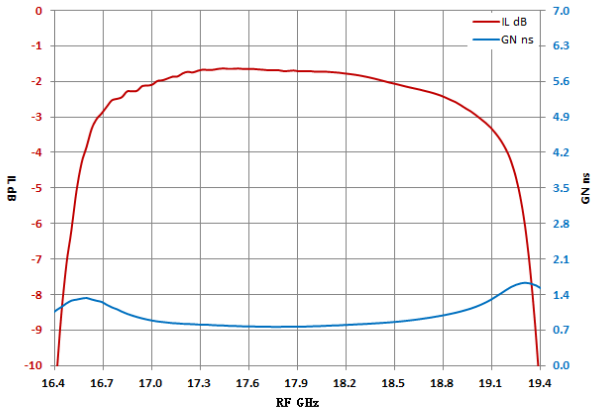
参考实物图

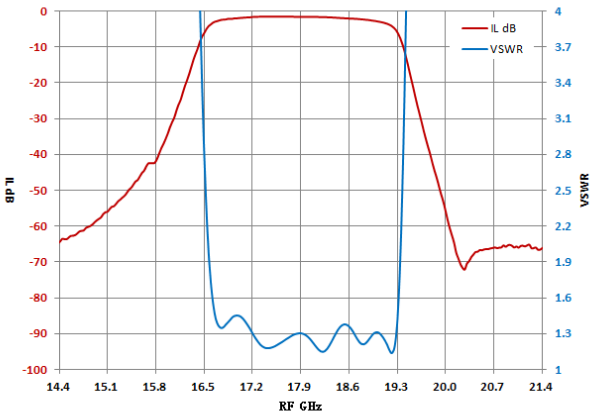


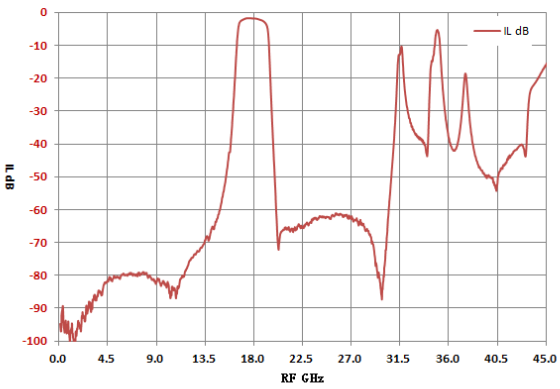
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

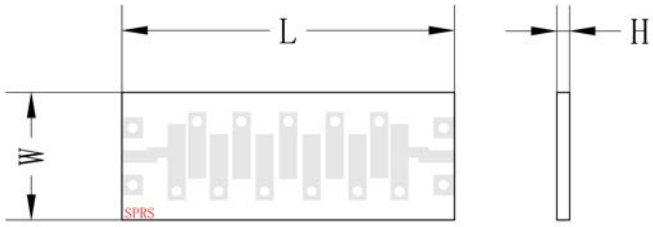
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	18.3	GHz
工作带宽	17.0-19.6	GHz
中心损耗	2.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-14.9GHz	dBc
带外抑制	40@22.2-43.0GHz	dBc

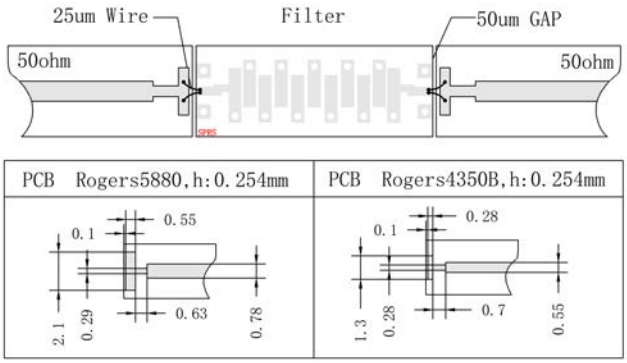
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



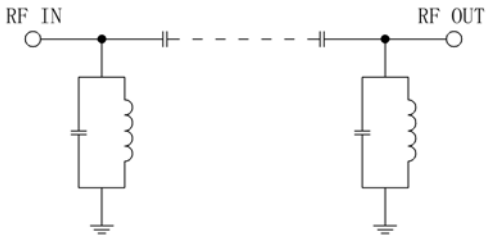
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.87mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

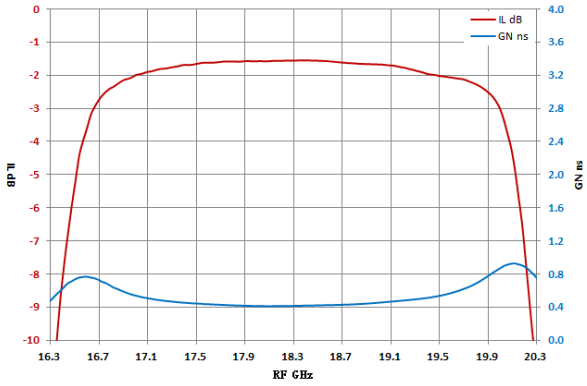
参考实物图

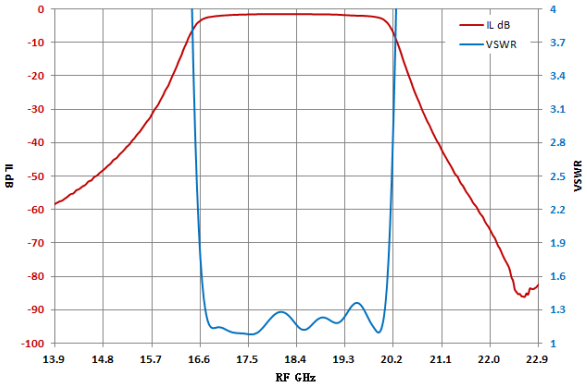


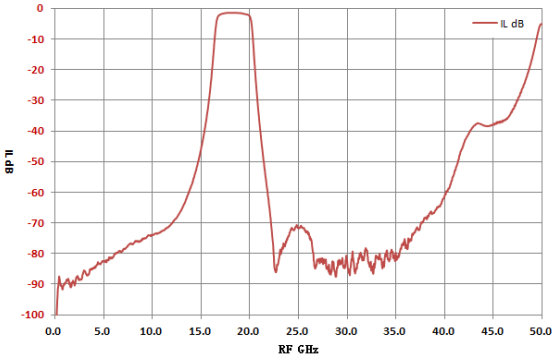
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

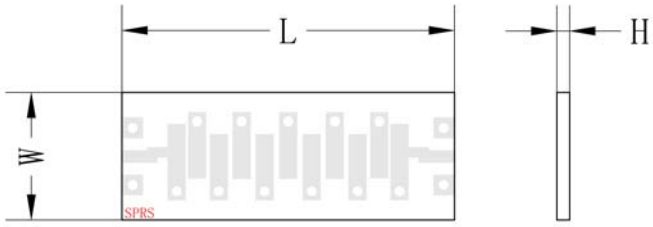
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	18.5	GHz
工作带宽	17.0-20.0	GHz
中心损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-15.1GHz	dBc
带外抑制	40@22.1-42.0GHz	dBc

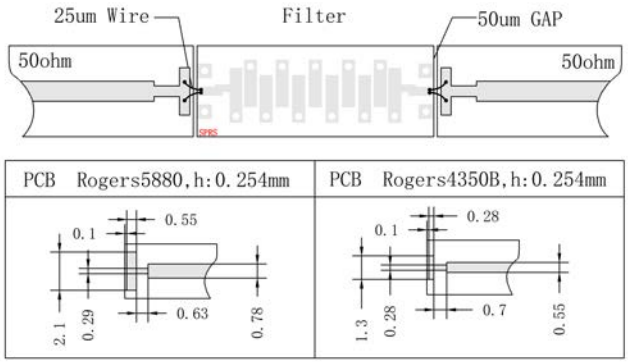
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



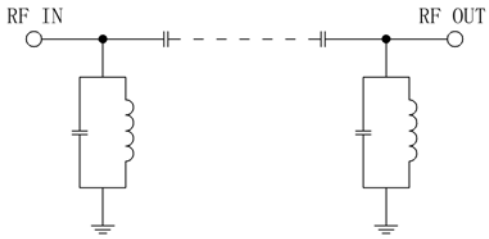
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

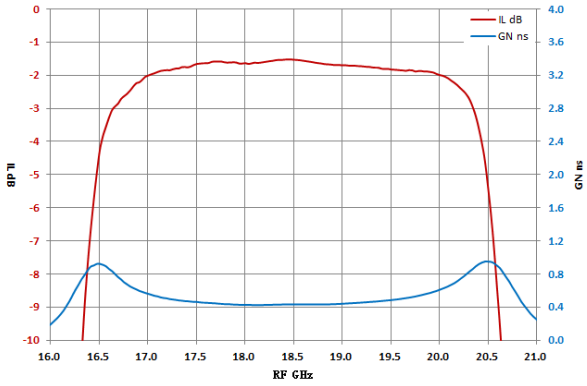
参考实物图

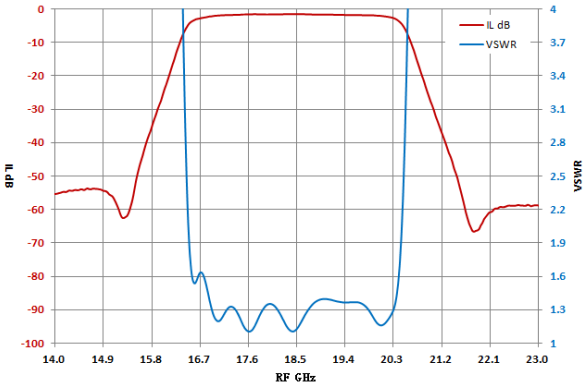


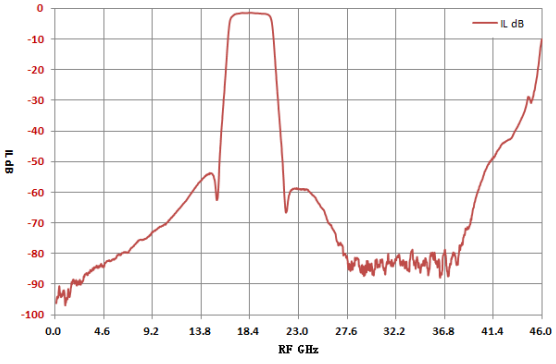
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

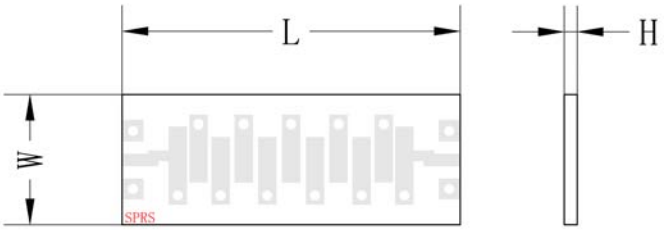
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	18.5	GHz
工作带宽	17.0-20.0	GHz
中心损耗	1.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-14.8GHz	dBc
带外抑制	40@21.7-43.0GHz	dBc

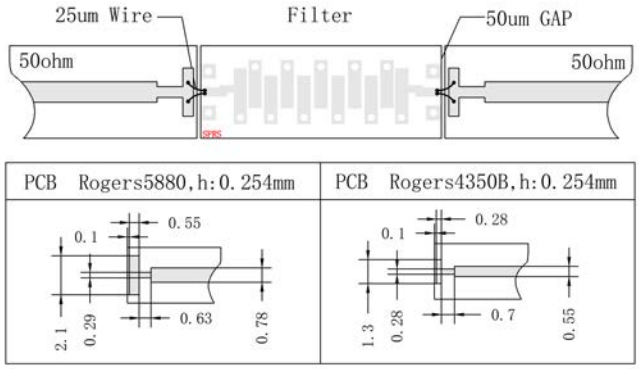
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

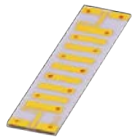
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

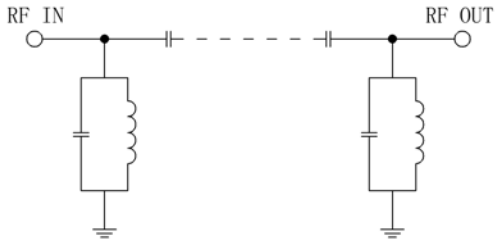
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

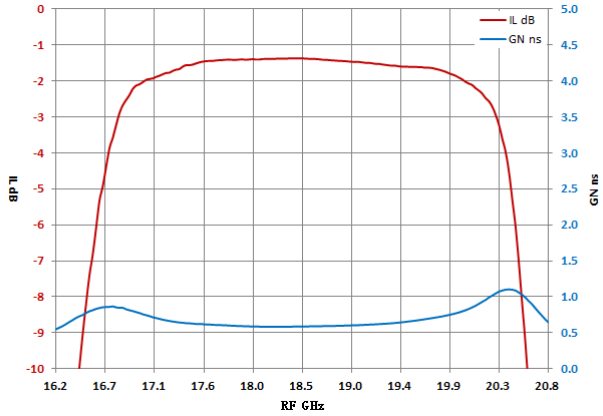
参考图

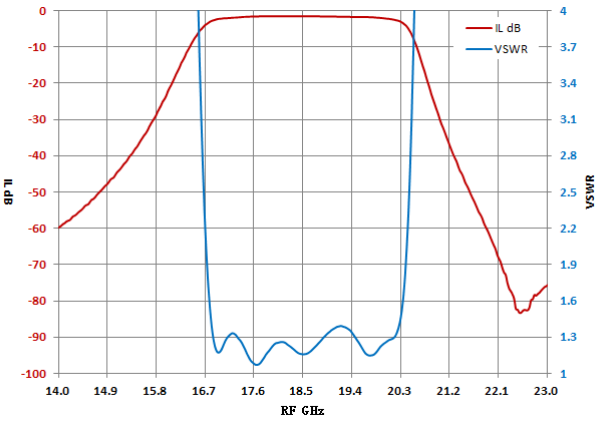


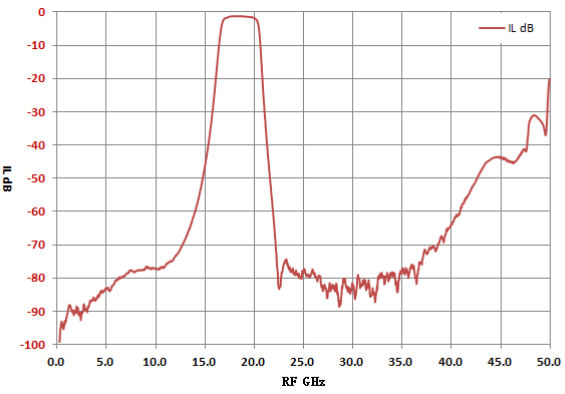
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



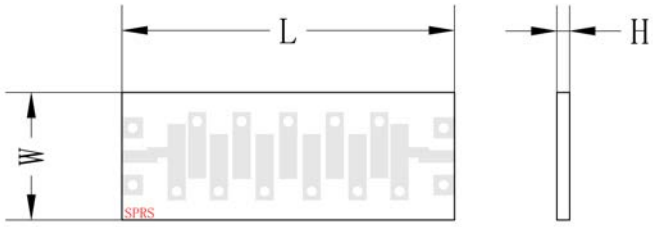
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	19.6	GHz
工作带宽	17.0-22.2	GHz
中心损耗	1.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-14.5GHz	dBc
带外抑制	40@24.5-44.0GHz	dBc

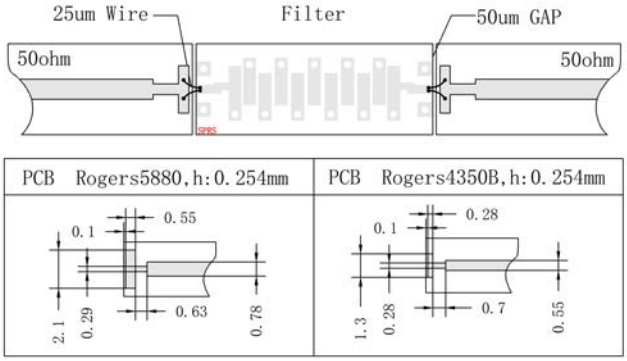
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



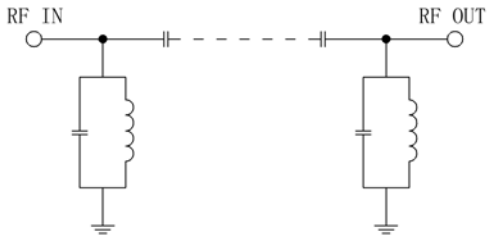
推荐装配图



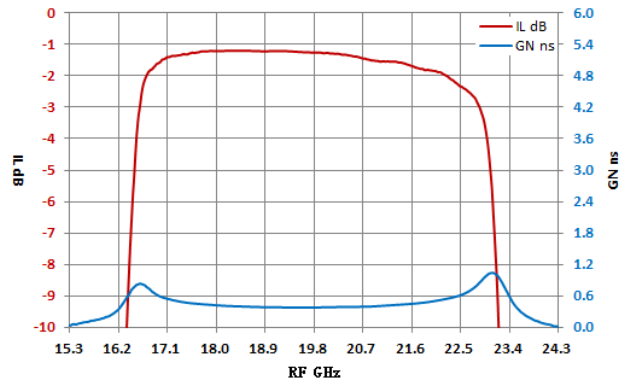
注意事项

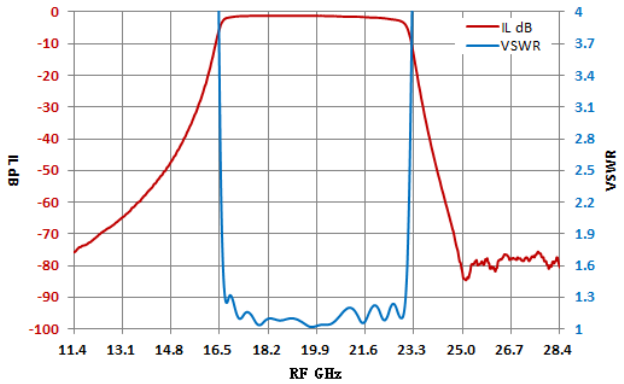
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

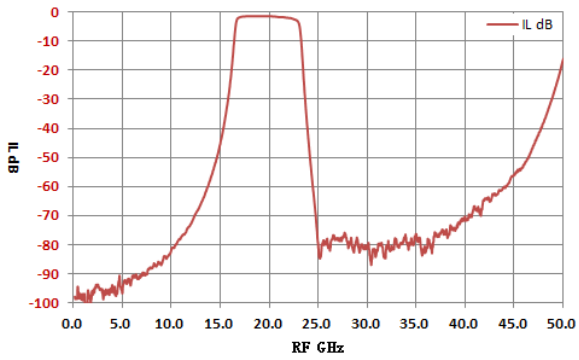
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

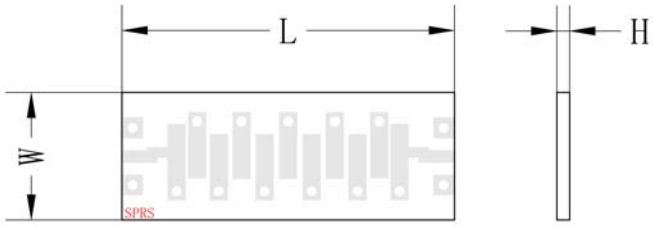
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	20.2	GHz
工作带宽	17.0-23.4	GHz
中心损耗	1.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-13.1GHz	dBc
带外抑制	40@27.0-43.0GHz	dBc

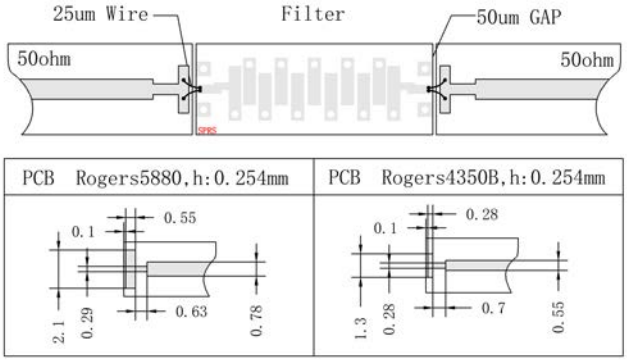
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



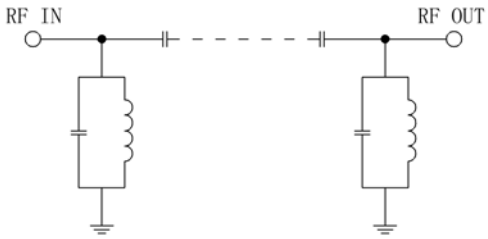
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

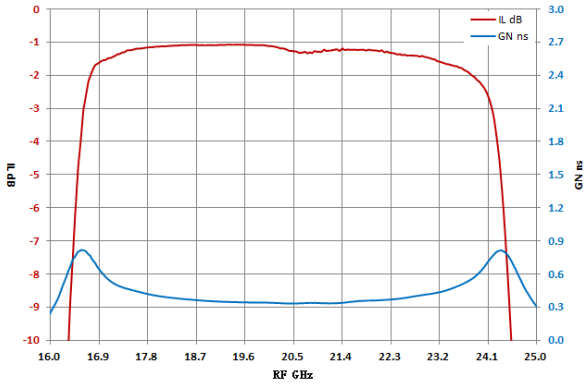
参考实物图

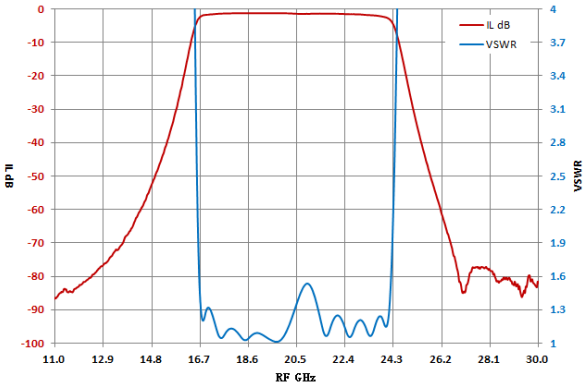


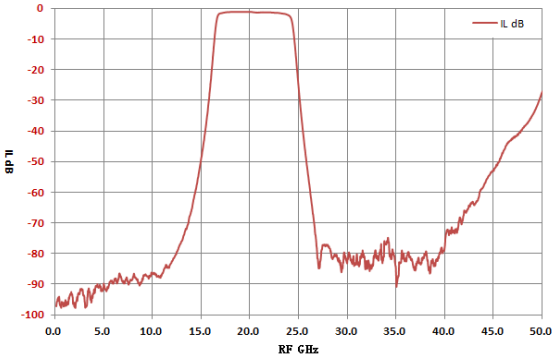
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

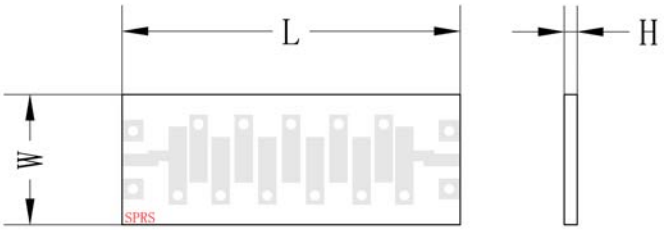
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	17.1	GHz
工作带宽	17.05-17.15	GHz
中心损耗	6.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-16.2GHz	dBc
带外抑制	40@17.8-42.0GHz	dBc

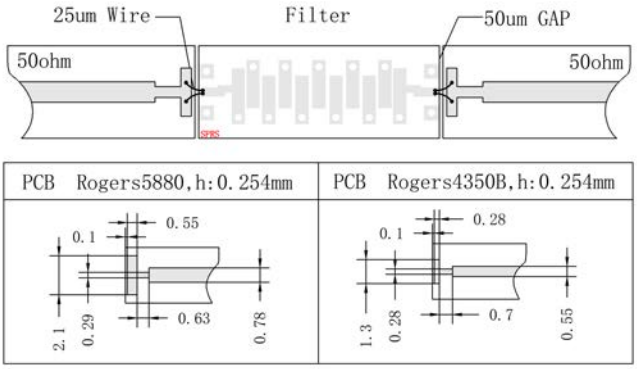
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：8.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

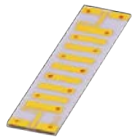
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

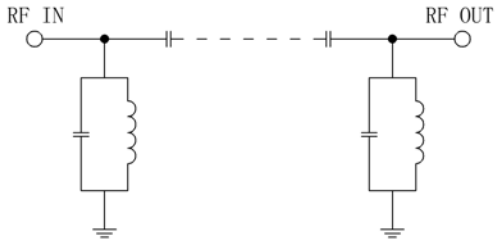
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

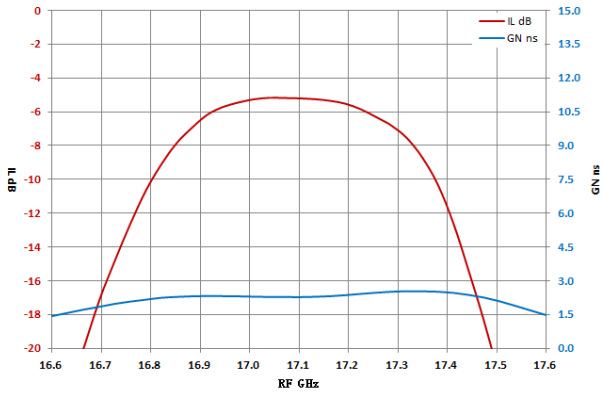
参考图

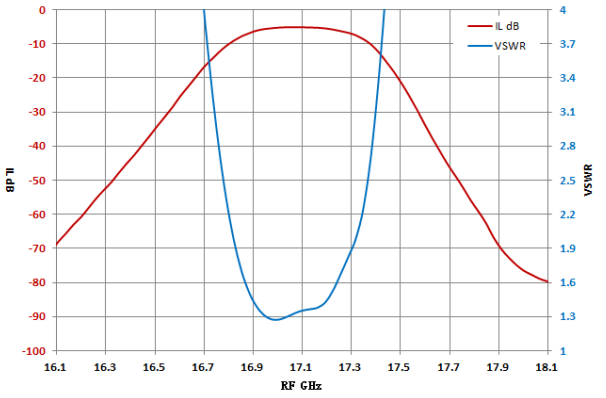


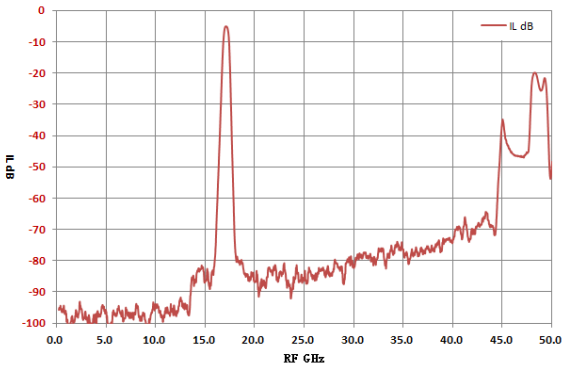
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



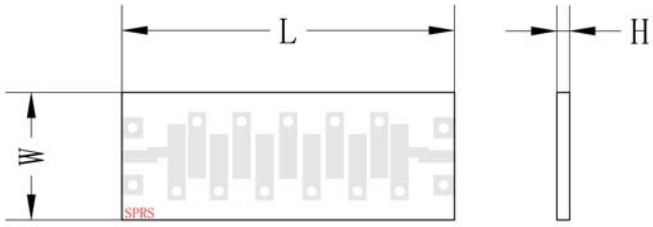
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	19.5	GHz
工作带宽	17.2-21.8	GHz
中心损耗	1.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-15.5GHz	dBc
带外抑制	40@23.7-45.0GHz	dBc

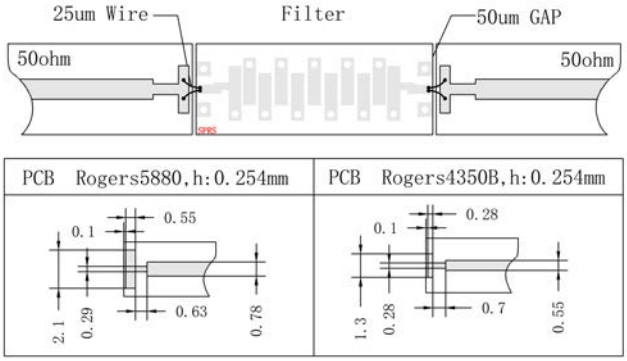
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



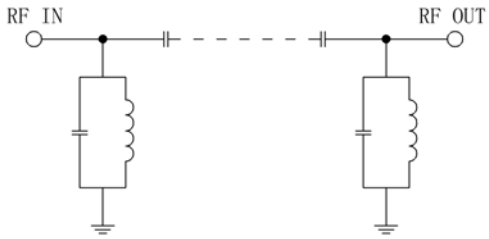
推荐装配图



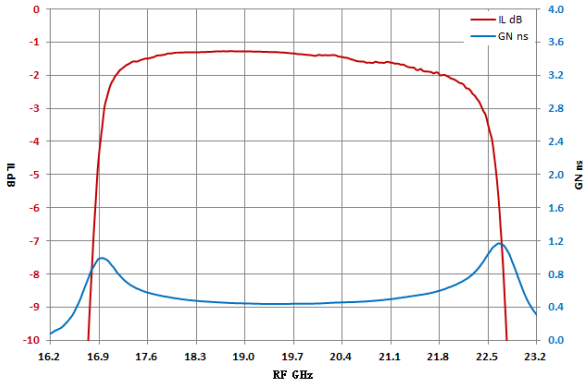
注意事项

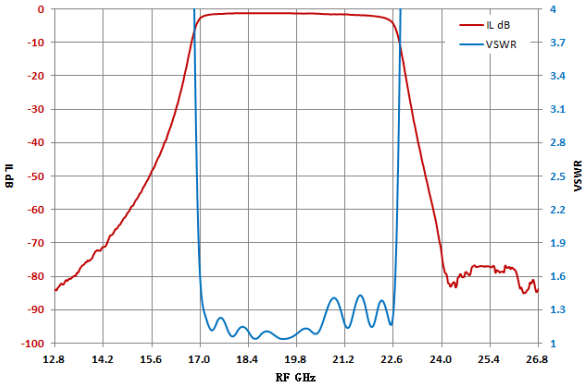
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

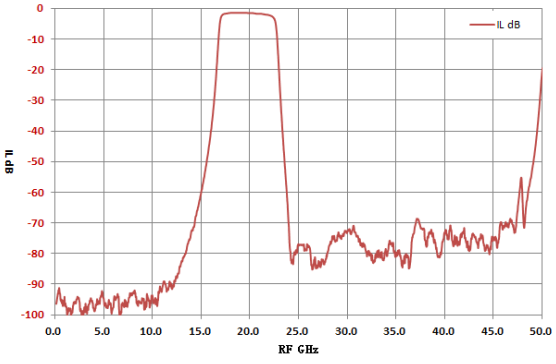
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

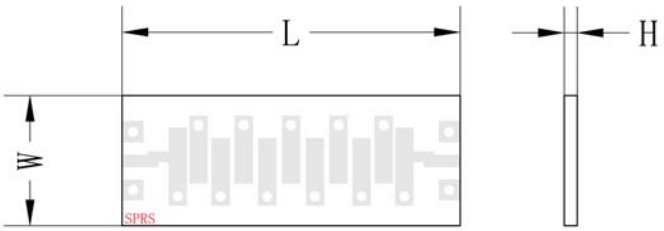
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	19.5	GHz
工作带宽	17.2-21.8	GHz
中心损耗	1.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	60@DC-15.0GHz	dBc
带外抑制	60@24.4-43.0GHz	dBc

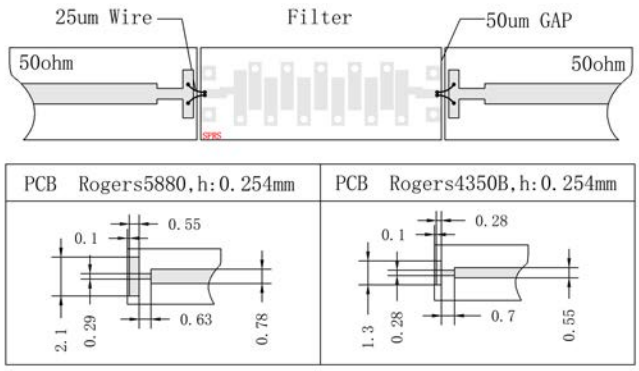
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

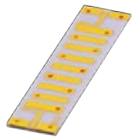
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

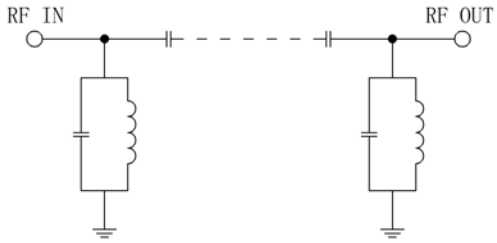
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

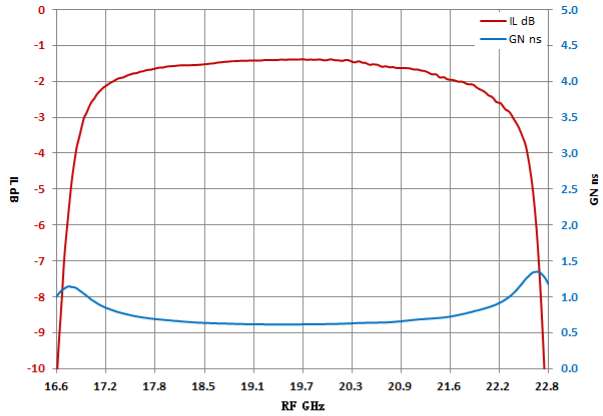
参考图

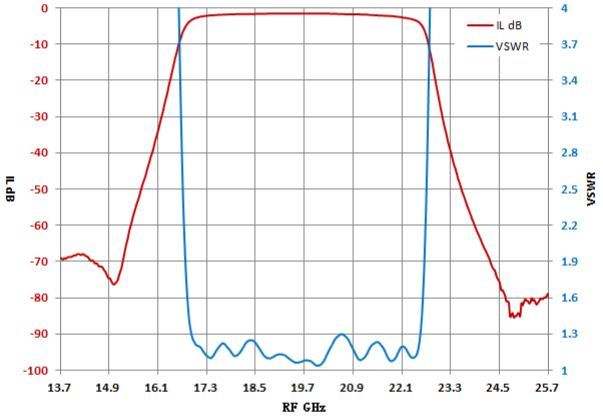


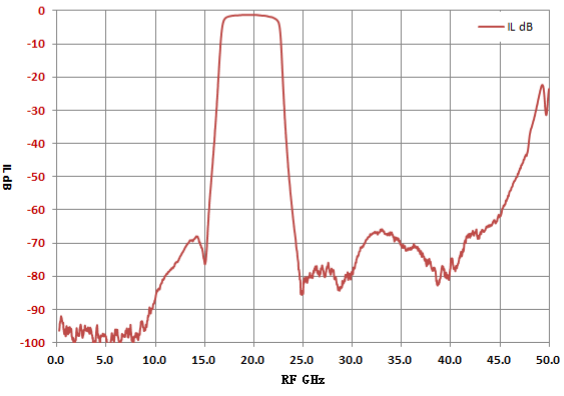
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

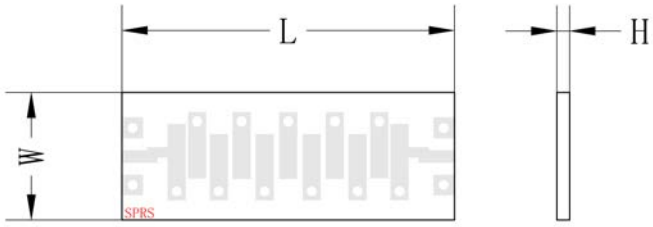
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	19.9	GHz
工作带宽	17.2-22.6	GHz
中心损耗	1.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-15.0GHz	dBc
带外抑制	40@25.1-44.0GHz	dBc

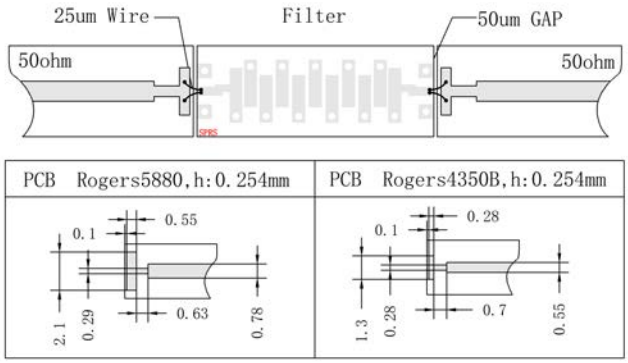
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



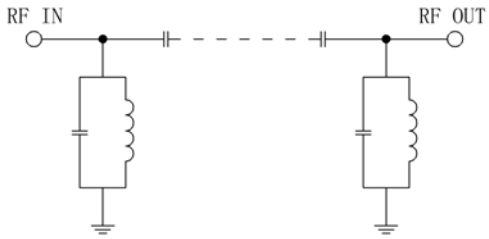
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

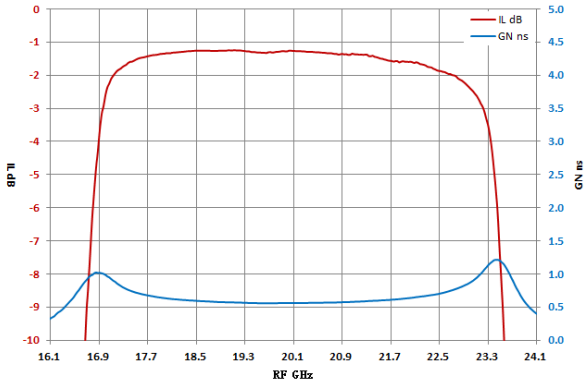
参考实物图

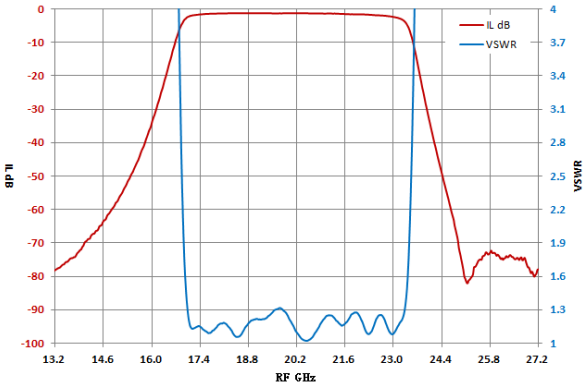


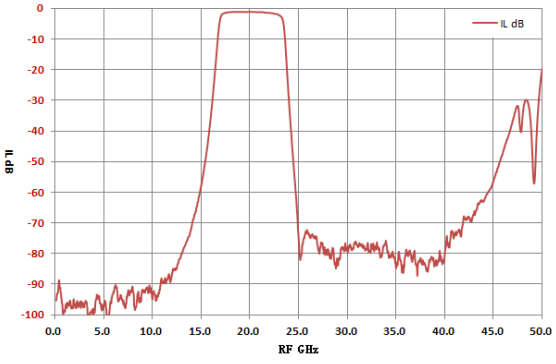
原理图



典型曲线







陶瓷滤波器 STBP201-5R8-K406

工作带宽 17.2-23.0GHz,带外抑制 40@DC-14.8GHz,40@25.7-45.0GHz

产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



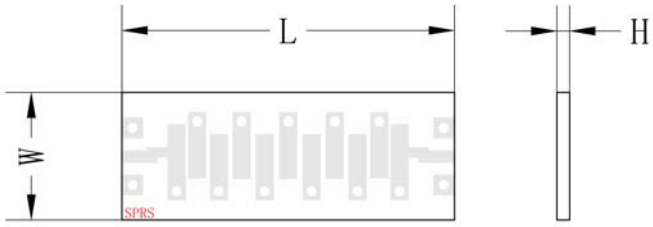
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	20.1	GHz
工作带宽	17.2-23.0	GHz
中心损耗	1.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-14.8GHz	dBc
带外抑制	40@25.7-45.0GHz	dBc

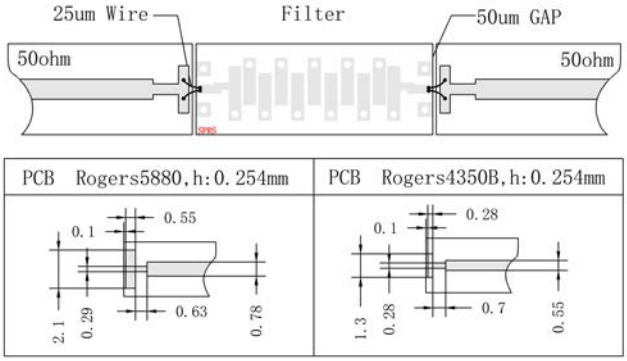
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



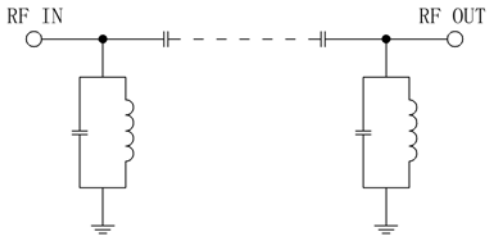
推荐装配图



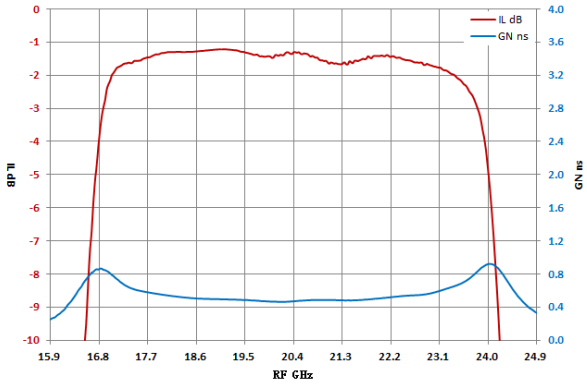
注意事项

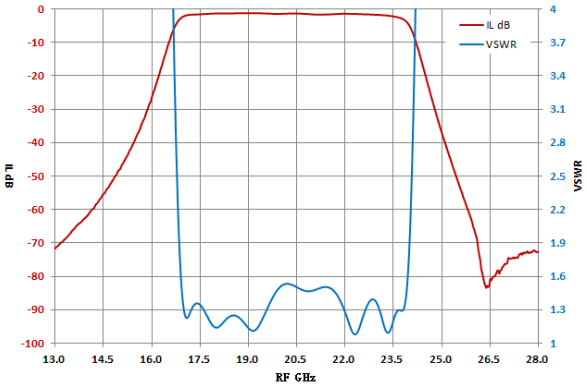
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

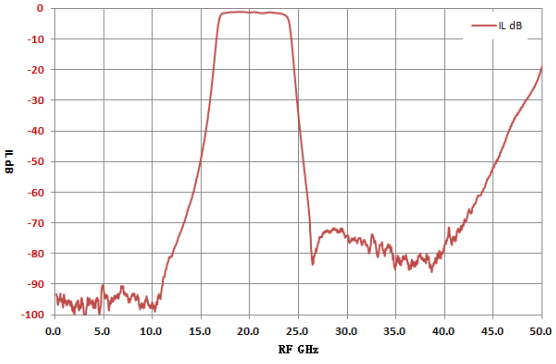
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

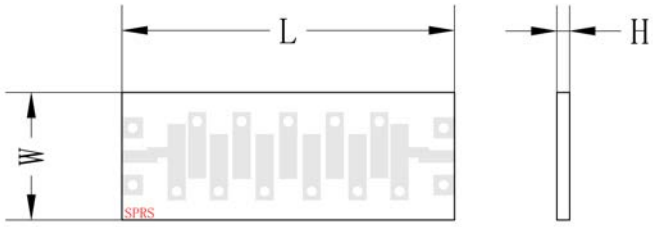
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	21.9	GHz
工作带宽	17.2-26.6	GHz
中心损耗	1.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-13.0GHz	dBc
带外抑制	40@29.4-43.0GHz	dBc

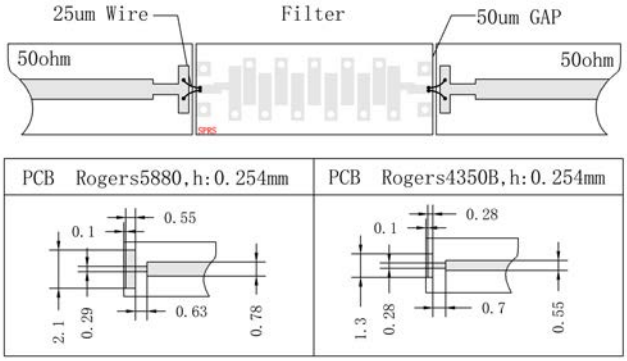
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



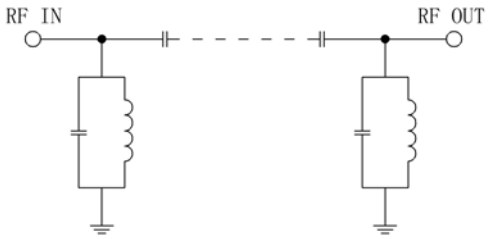
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.87mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

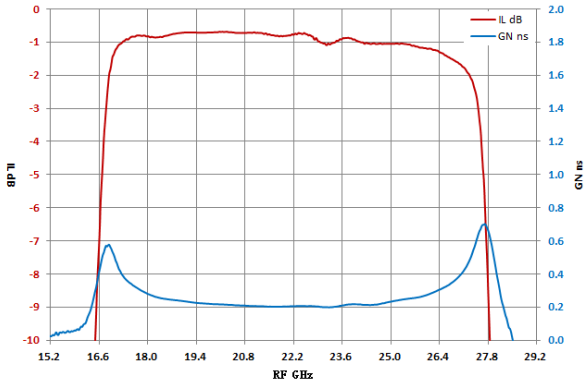
参考实物图

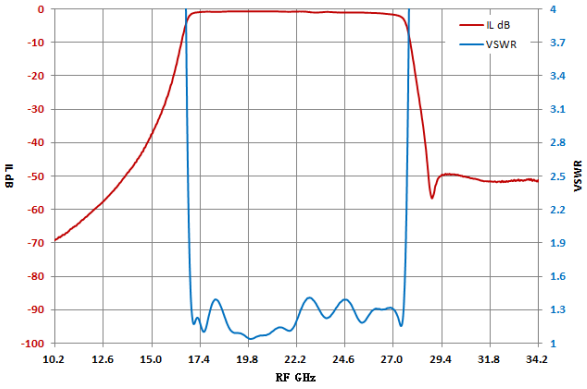


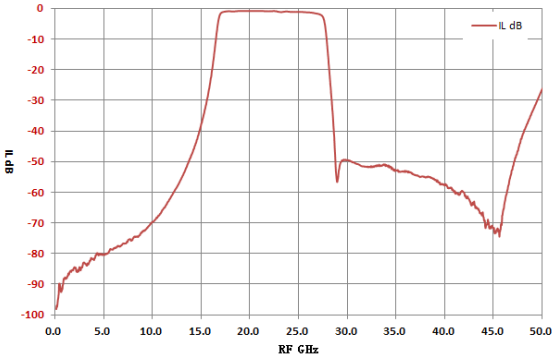
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



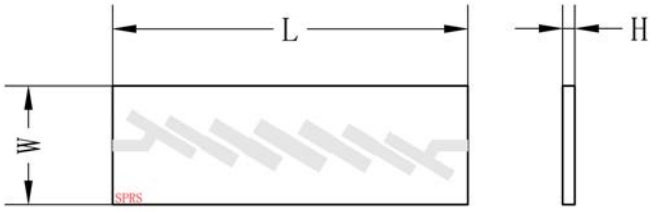
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	18.1	GHz
工作带宽	17.3-18.8	GHz
中心损耗	1.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-14.4GHz	dBc
带外抑制	40@21.5-26.0GHz	dBc

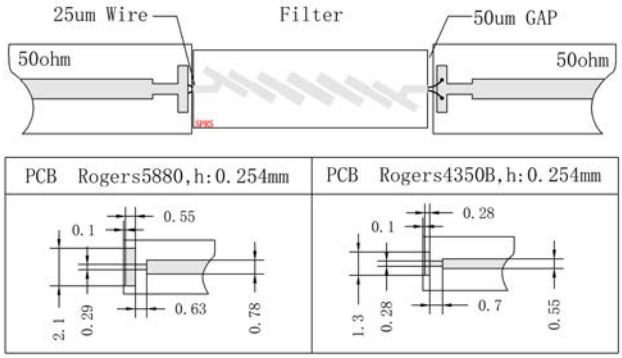
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



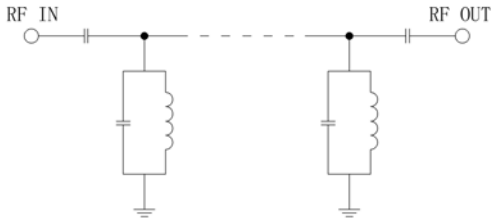
推荐装配图



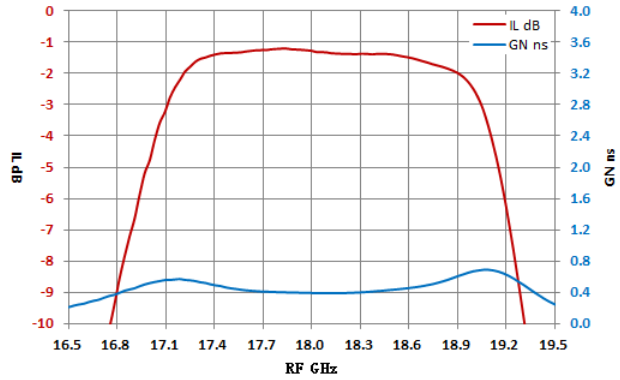
注意事项

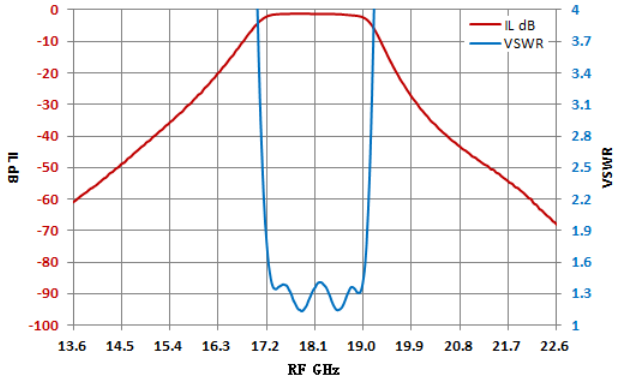
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

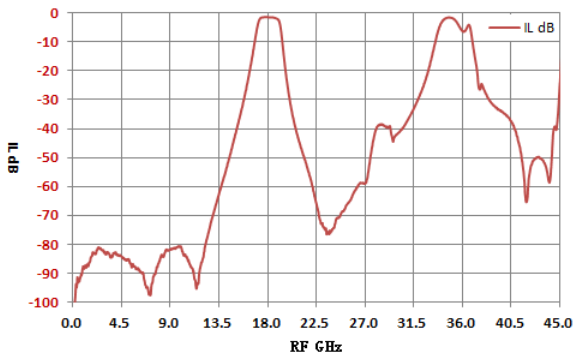
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

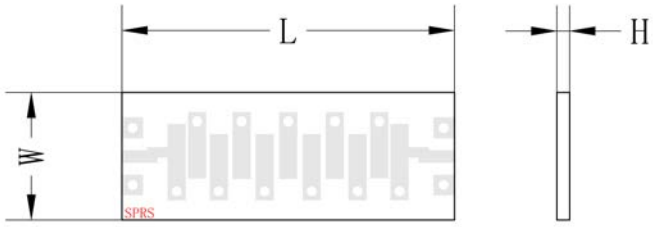
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	21.4	GHz
工作带宽	17.3-25.5	GHz
中心损耗	2.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-12.0GHz	dBc
带外抑制	40@28.6-43.0GHz	dBc

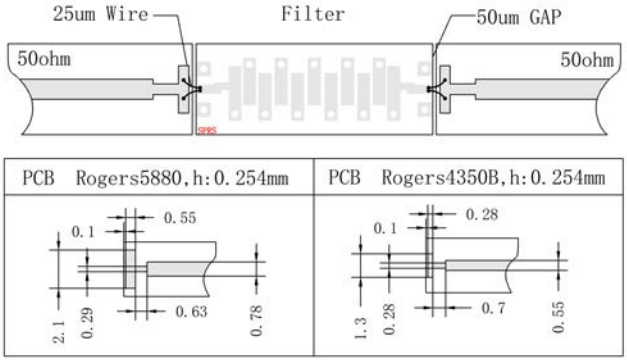
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



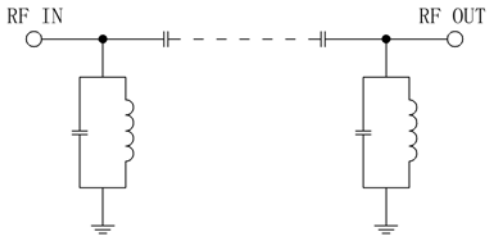
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.87mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

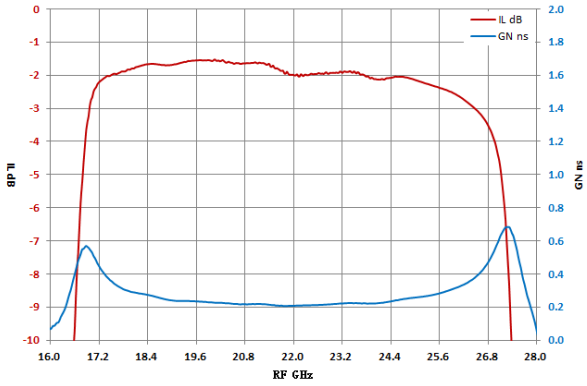
参考实物图

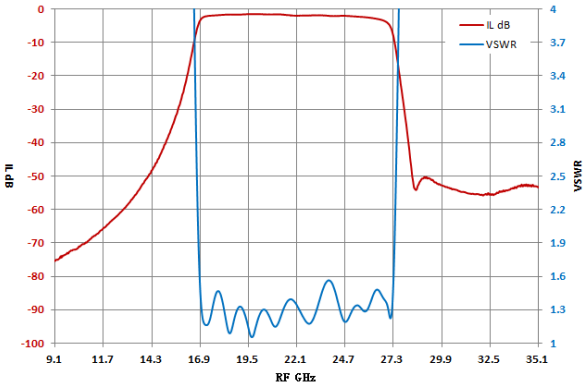


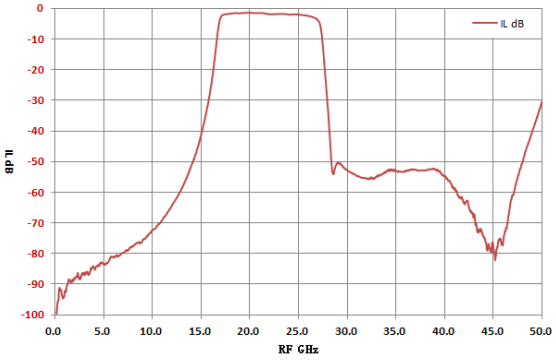
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



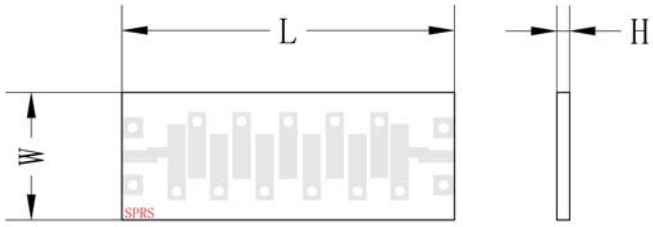
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	22.0	GHz
工作带宽	17.3-26.7	GHz
中心损耗	1.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-14.2GHz	dBc
带外抑制	40@29.2-47.0GHz	dBc

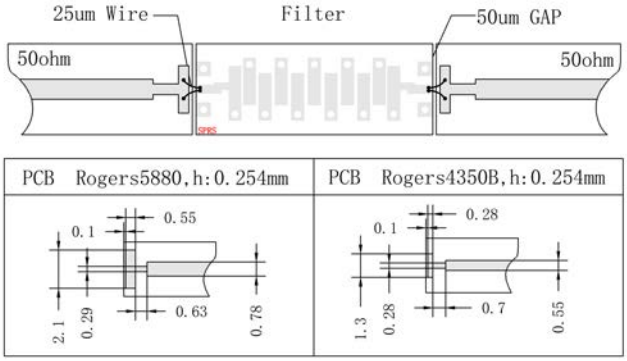
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



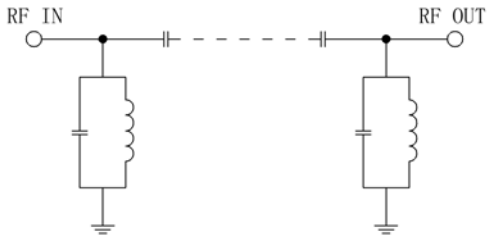
推荐装配图



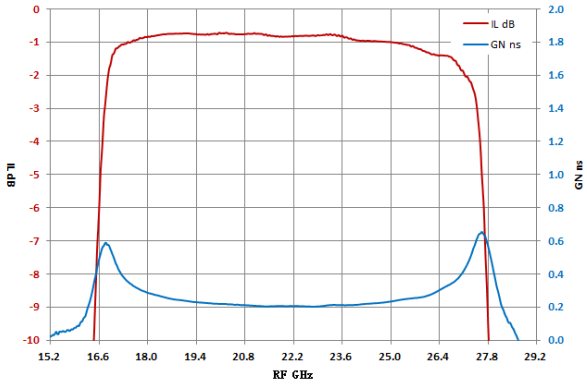
注意事项

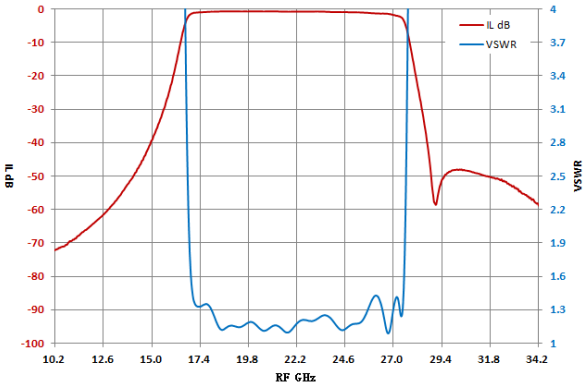
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

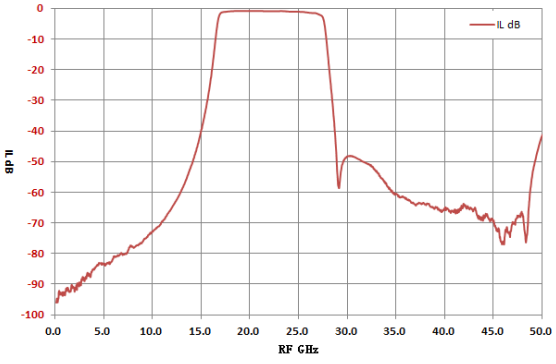
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



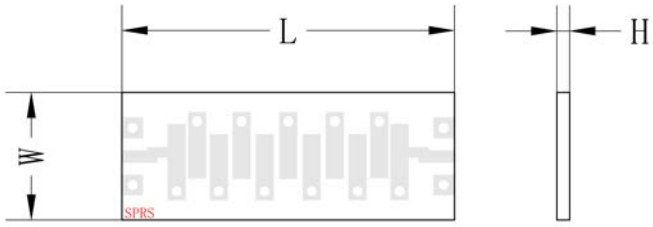
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	19.5	GHz
工作带宽	17.4-21.6	GHz
中心损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-15.5GHz	dBc
带外抑制	40@23.5-45.0GHz	dBc

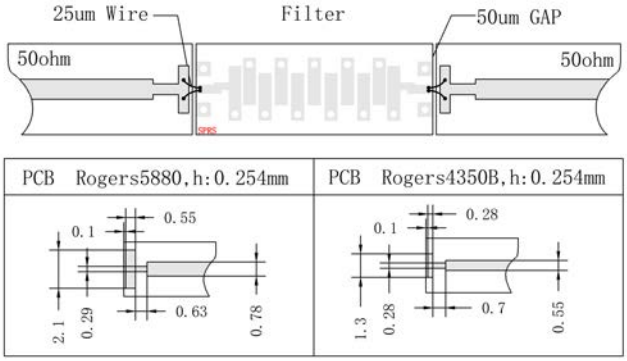
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



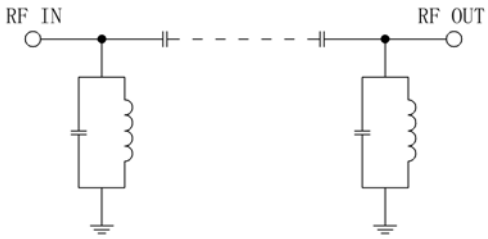
推荐装配图



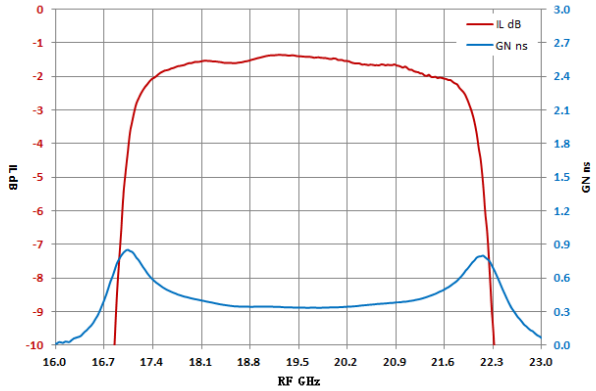
注意事项

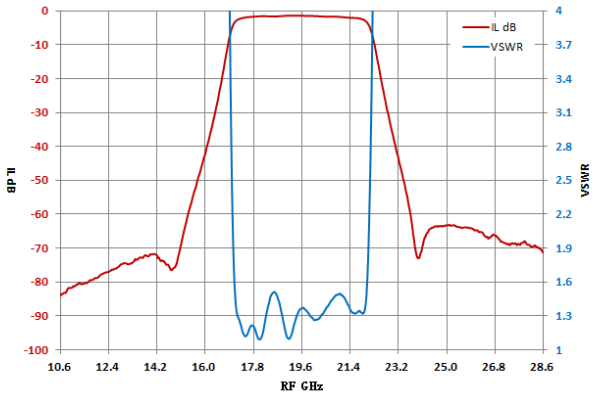
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

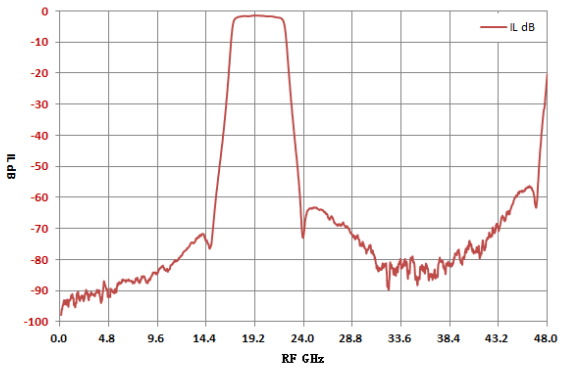
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

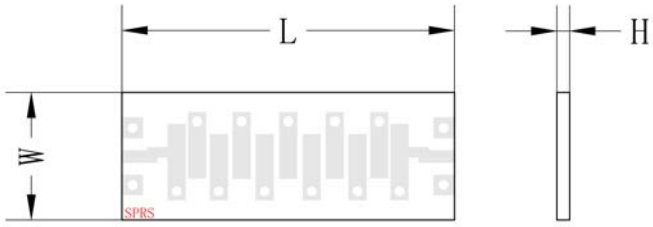
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	20.8	GHz
工作带宽	17.4-24.2	GHz
中心损耗	1.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-14.0GHz	dBc
带外抑制	40@27.4-42.0GHz	dBc

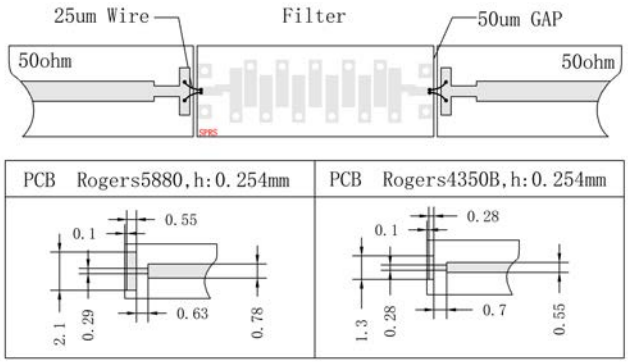
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：2.2，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



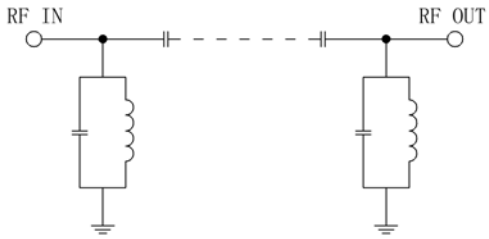
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.87mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

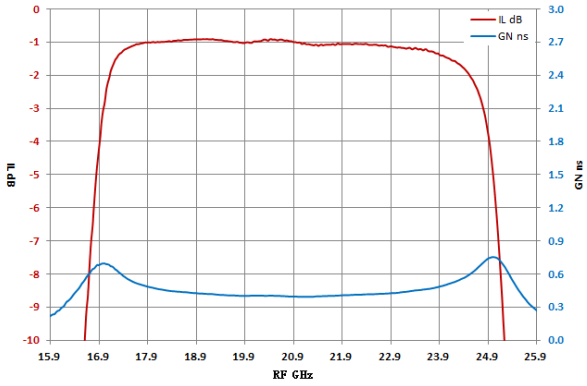
参考实物图

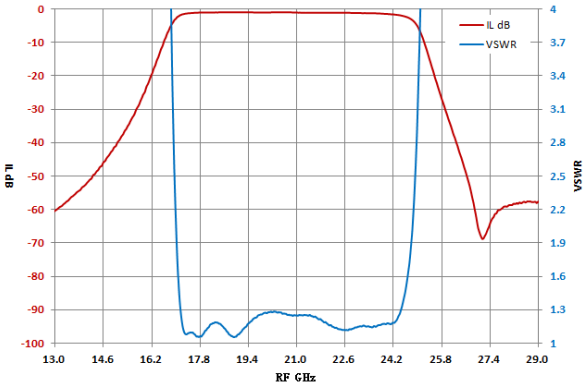


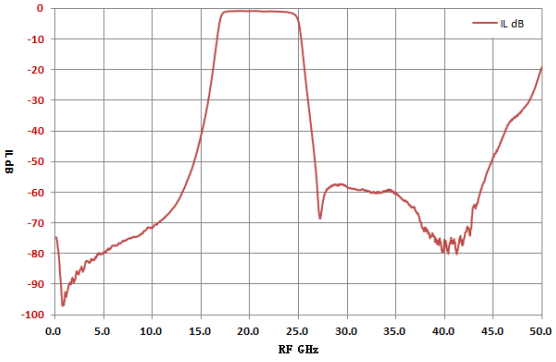
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

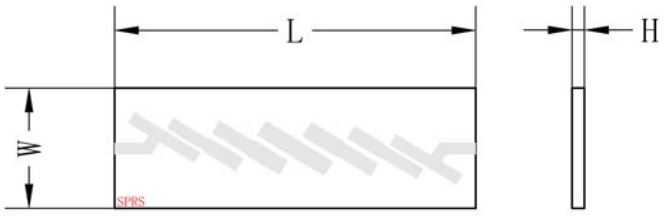
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	20.95	GHz
工作带宽	17.4-24.5	GHz
中心损耗	1.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-14.2GHz	dBc
带外抑制	40@26.7-47.0GHz	dBc

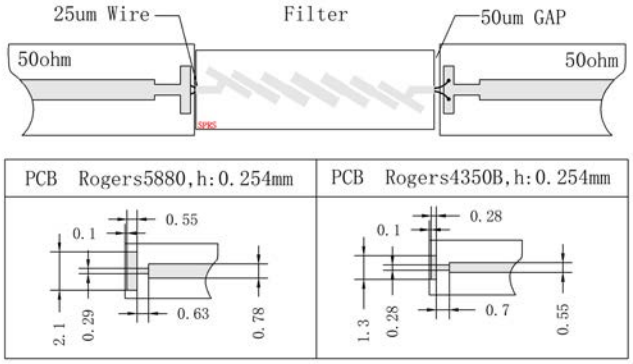
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：6.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

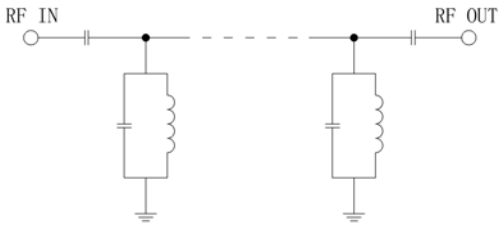
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

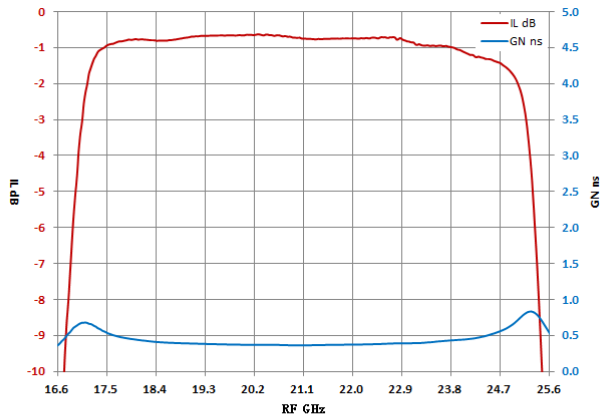
参考图

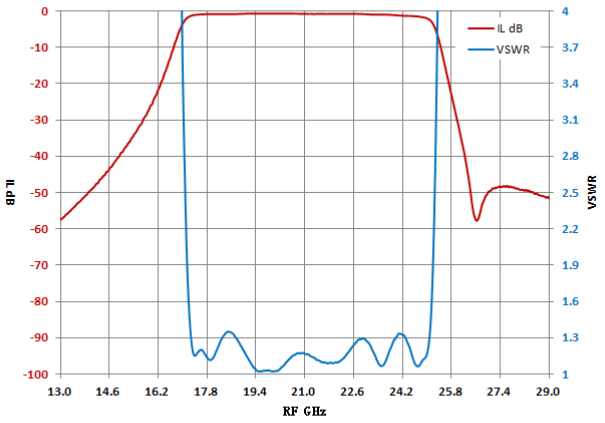


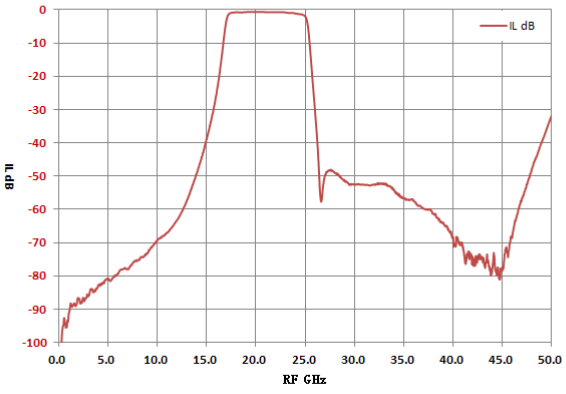
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



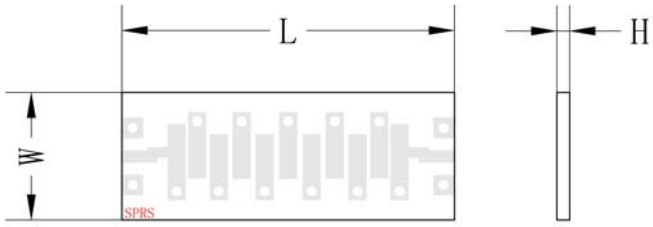
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	22.0	GHz
工作带宽	17.4-26.6	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-14.7GHz	dBc
带外抑制	40@30.0-52.0GHz	dBc

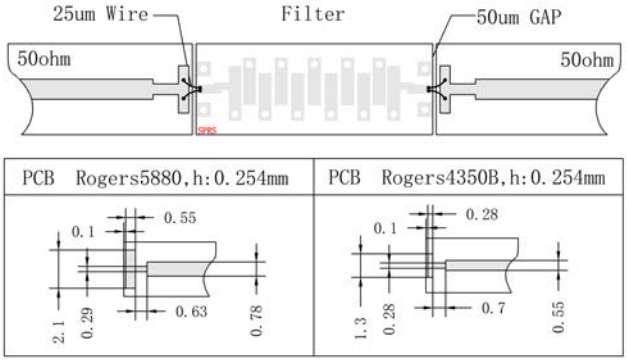
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



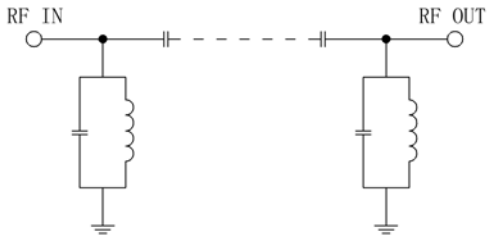
推荐装配图



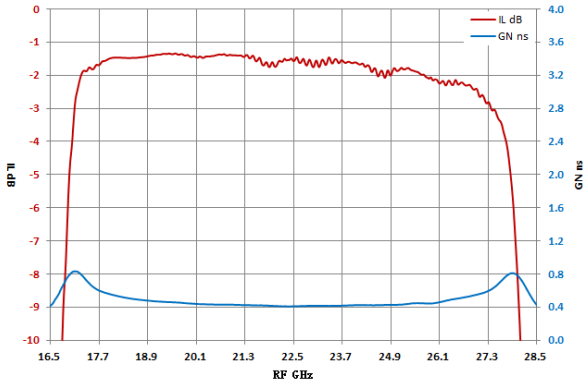
注意事项

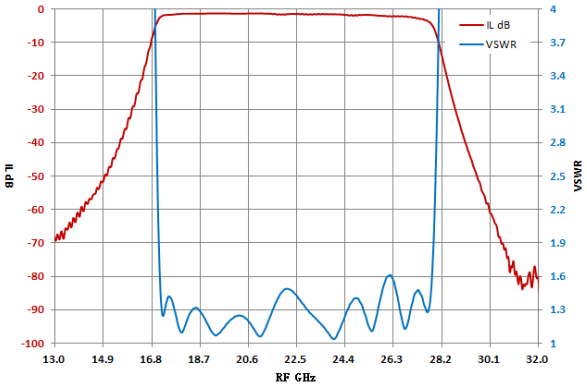
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

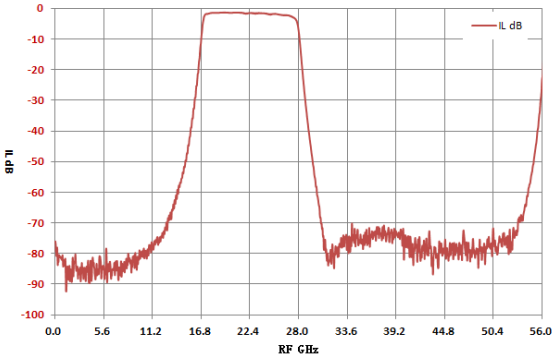
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

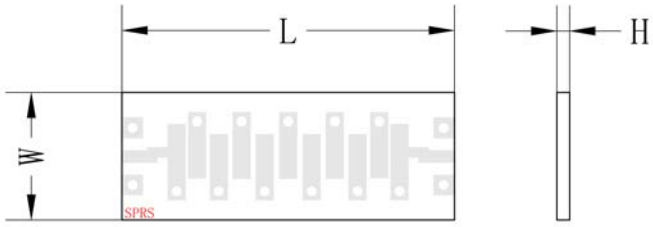
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	19.9	GHz
工作带宽	17.5-22.3	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-14.5GHz	dBc
带外抑制	40@25.0-32.5.0GHz	dBc

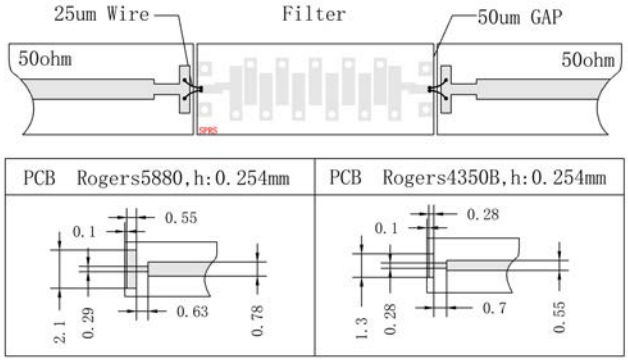
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



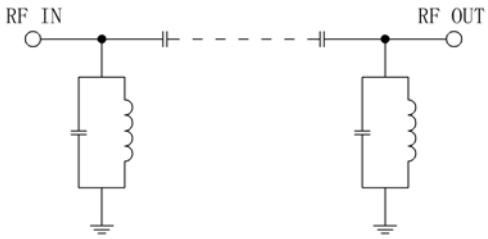
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

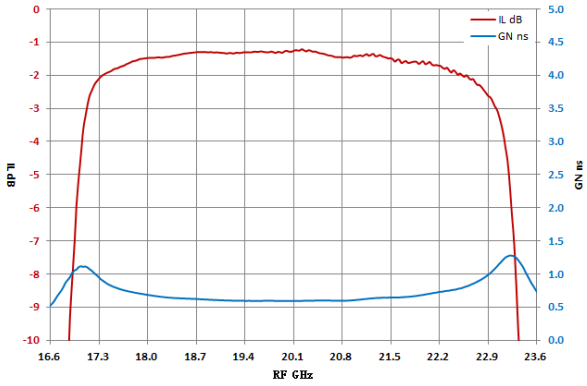
参考实物图

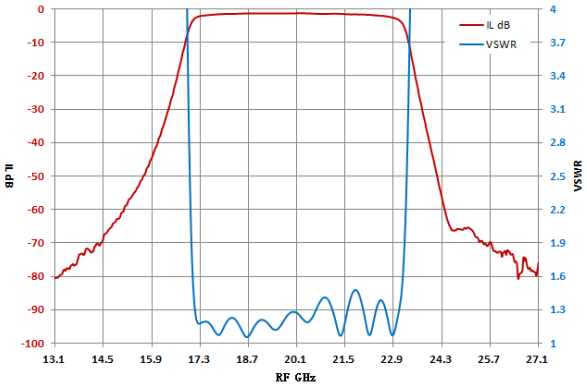


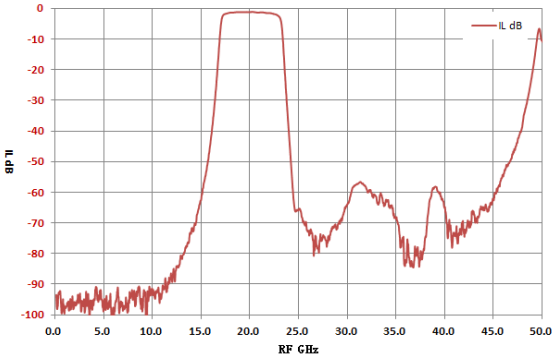
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



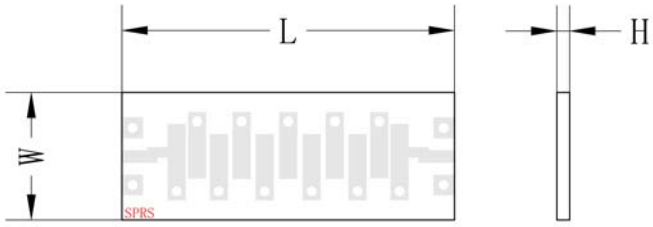
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	23.0	GHz
工作带宽	18.5-27.5	GHz
中心损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-15.5GHz	dBc
带外抑制	40@30.8-50.0GHz	dBc

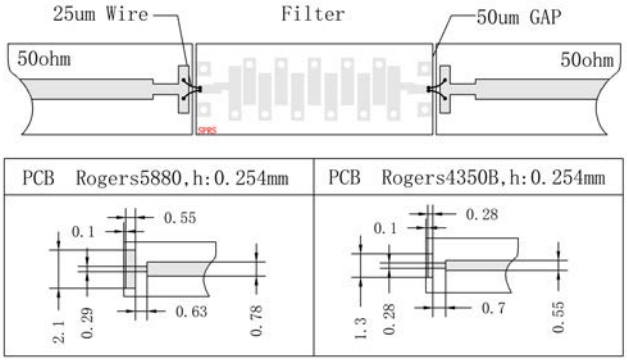
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



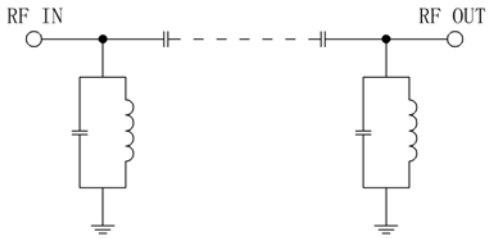
推荐装配图



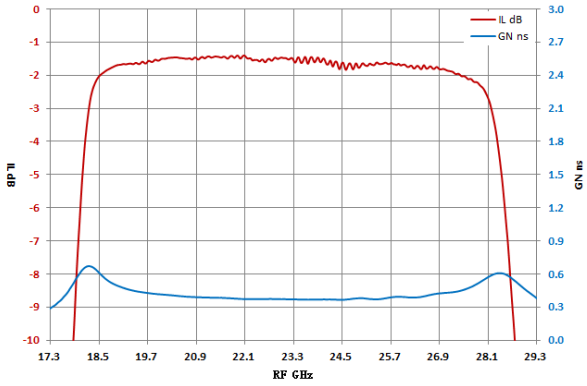
注意事项

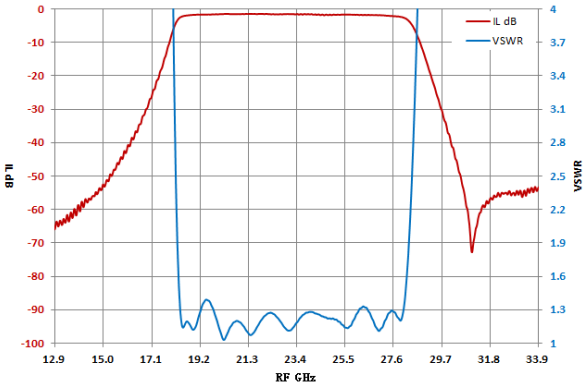
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

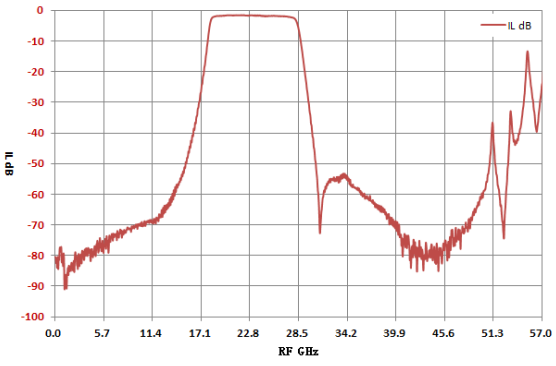
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



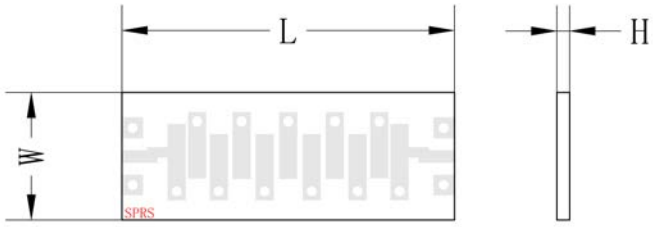
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	20.2	GHz
工作带宽	17.6-22.8	GHz
中心损耗	2.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-15.8GHz	dBc
带外抑制	40@25.2-47.0GHz	dBc

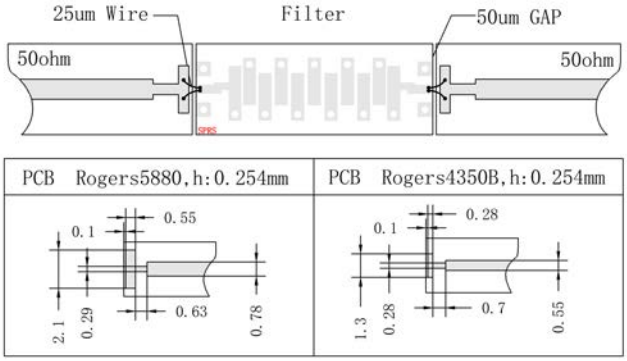
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



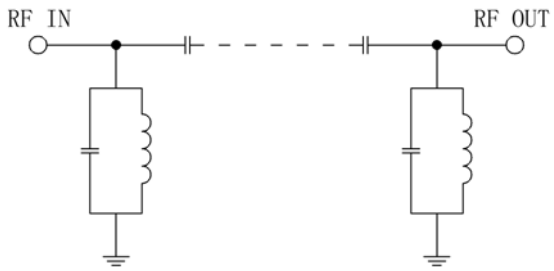
推荐装配图



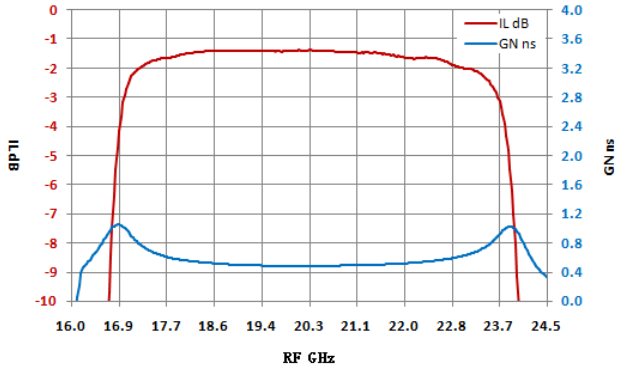
注意事项

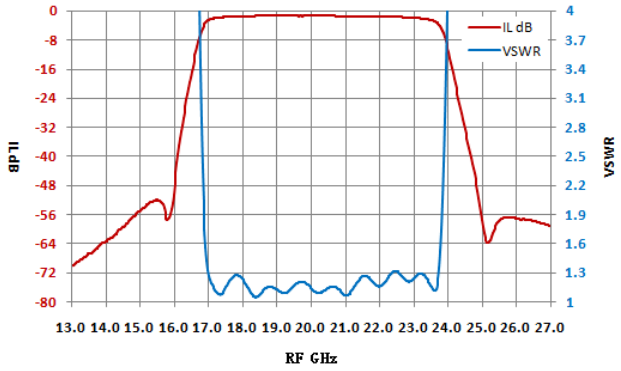
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

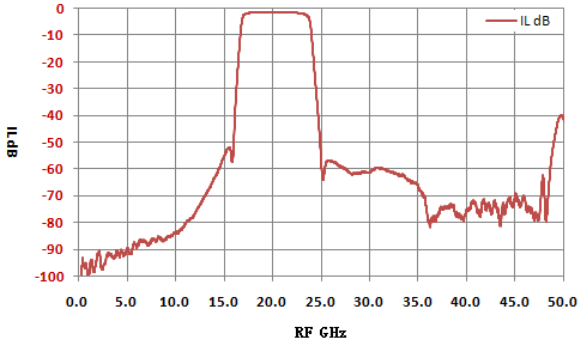
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



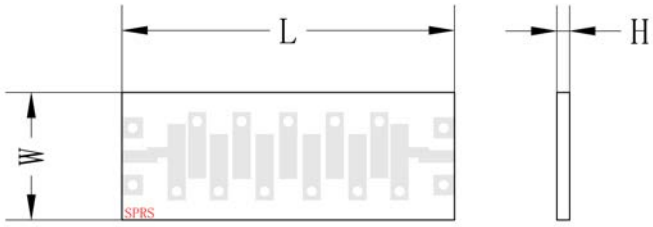
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	22.0	GHz
工作带宽	17.6-26.4	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-12.8GHz	dBc
带外抑制	28@28.0-45.0GHz	dBc

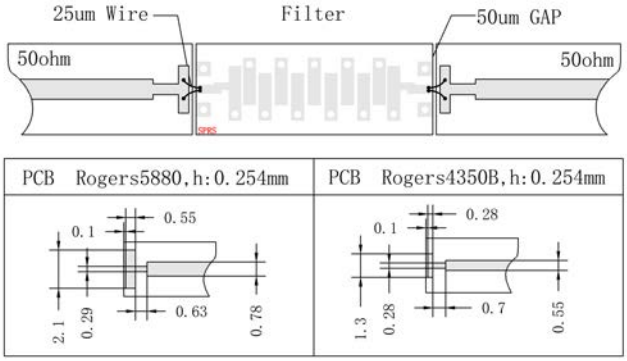
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



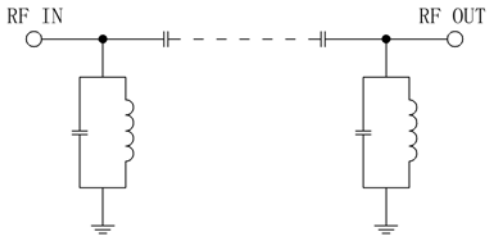
推荐装配图



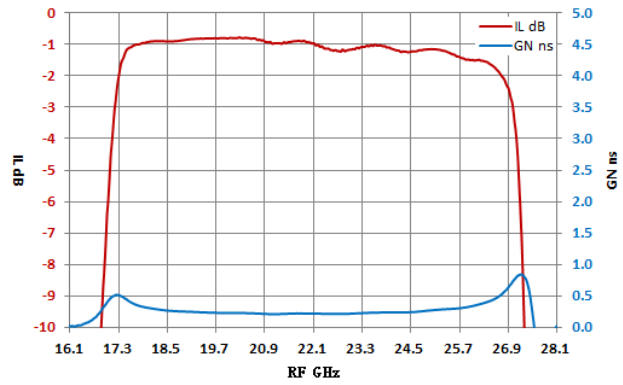
注意事项

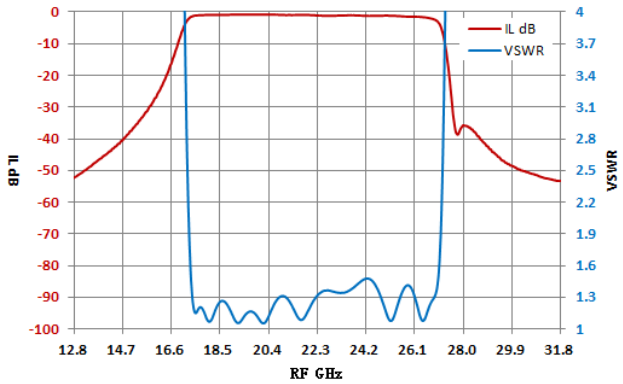
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

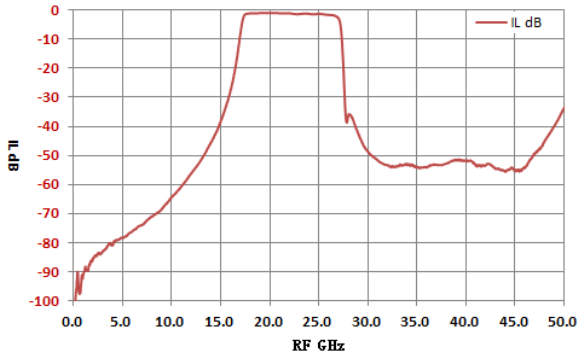
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

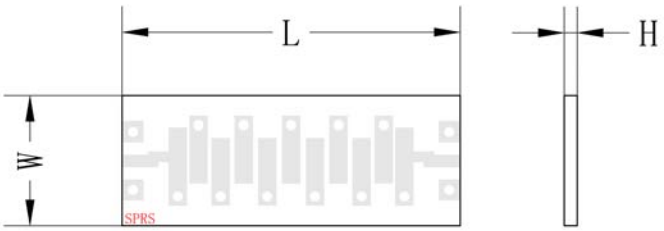
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	22.35	GHz
工作带宽	17.7-27.0	GHz
中心损耗	1.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-15.7GHz	dBc
带外抑制	40@29.5-50.0GHz	dBc

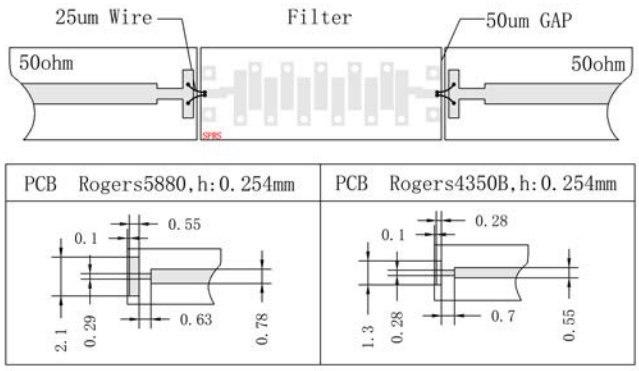
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：6.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

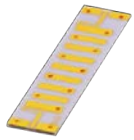
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

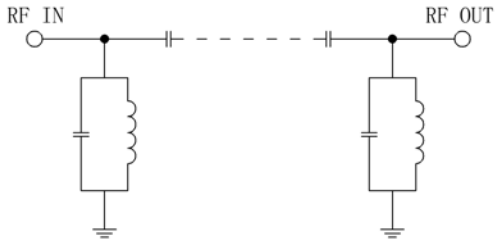
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

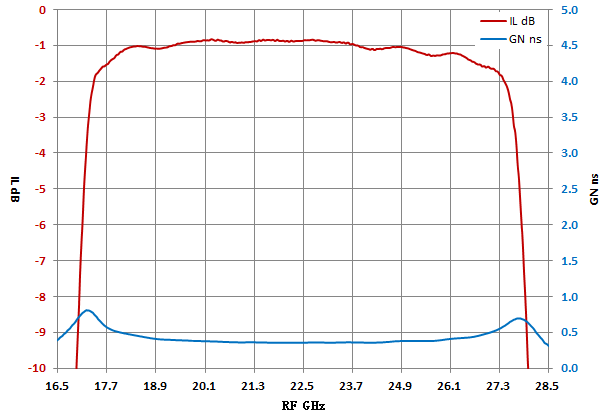
参考图

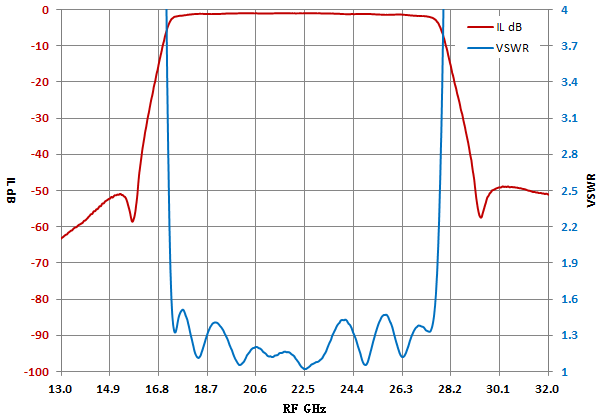


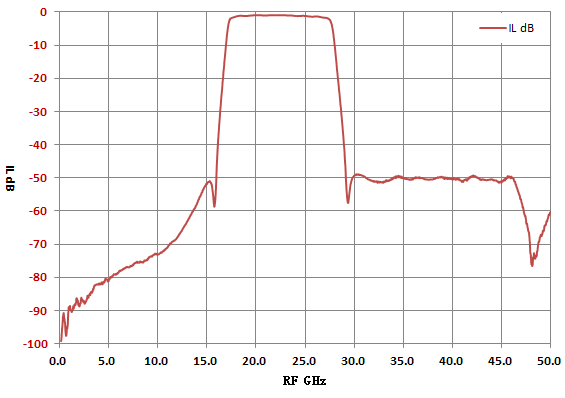
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

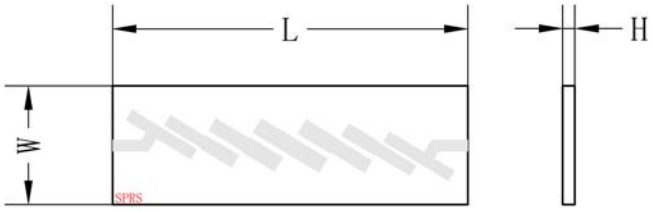
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	17.95	GHz
工作带宽	17.8-18.1	GHz
中心损耗	3.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	1.0	ns
带外抑制	40@DC-16.0GHz	dBc
带外抑制	40@20.0-44.0GHz	dBc

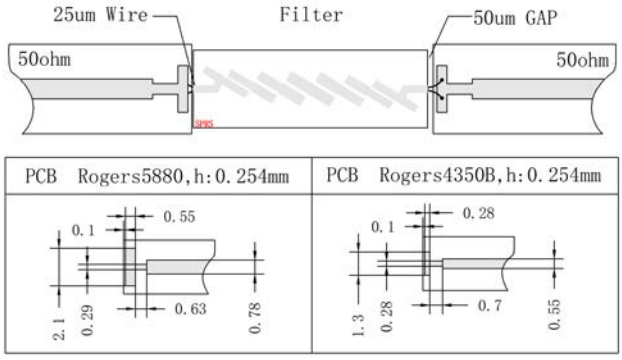
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：10.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



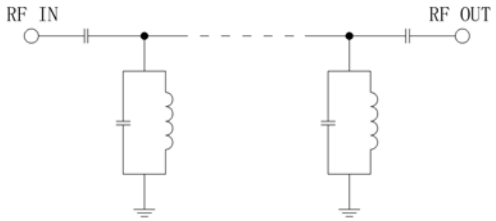
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

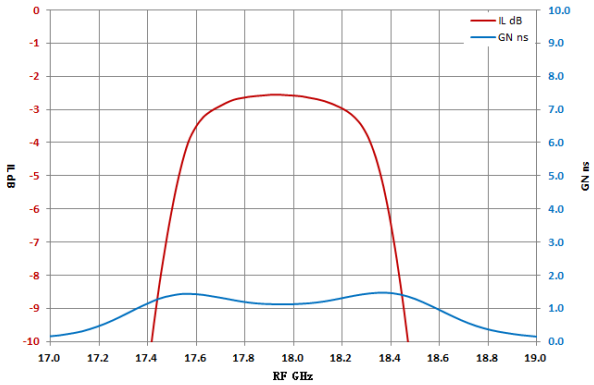
参考实物图

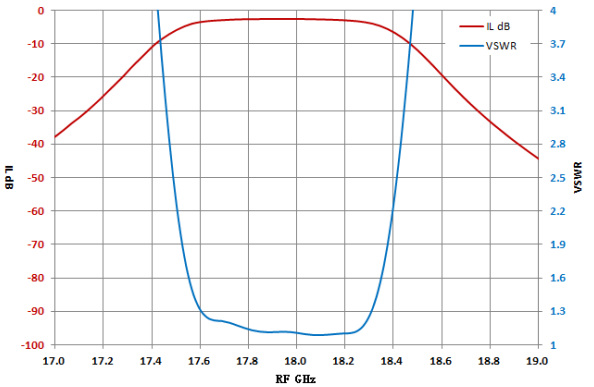


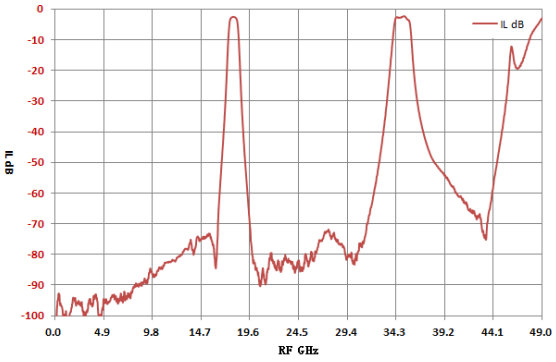
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

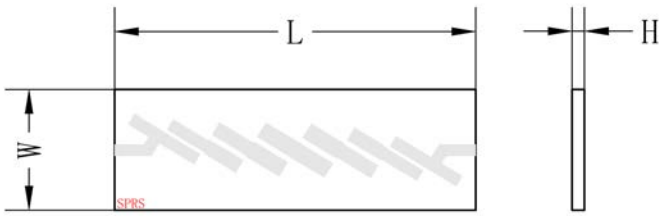
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	18.55	GHz
工作带宽	17.8-19.3	GHz
中心损耗	2.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	50@DC-16.2GHz	dBc
带外抑制	50@20.8-28.0GHz	dBc

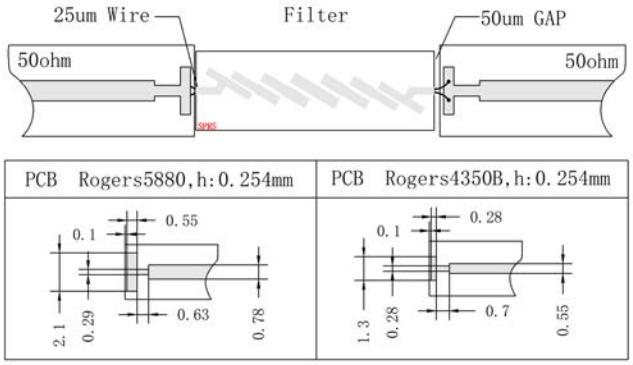
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：8.0，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

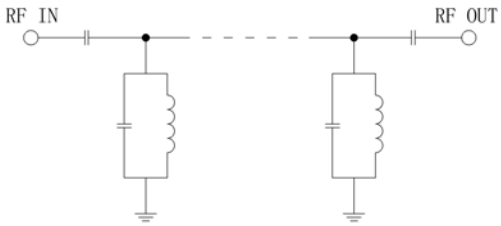
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

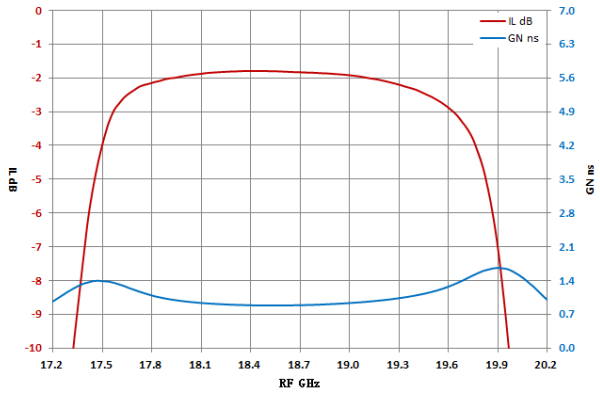
参考图

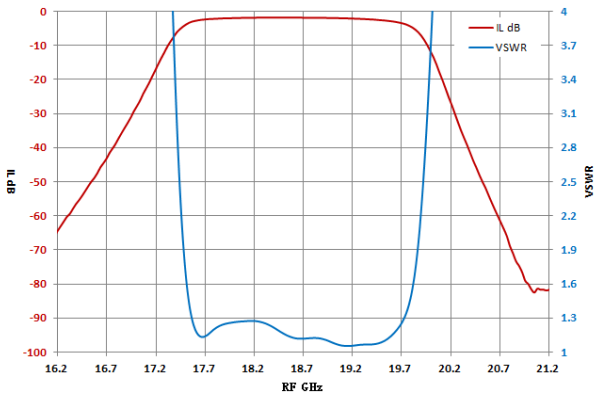


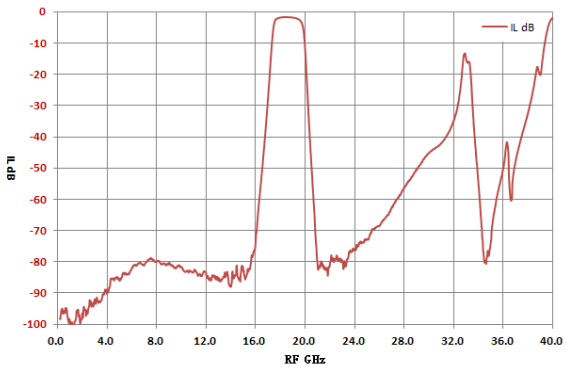
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

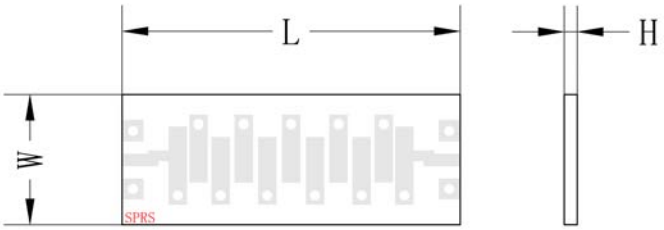
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	18.8	GHz
工作带宽	17.8-19.8	GHz
中心损耗	2.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-16.5GHz	dBc
带外抑制	40@21.4-45.0GHz	dBc

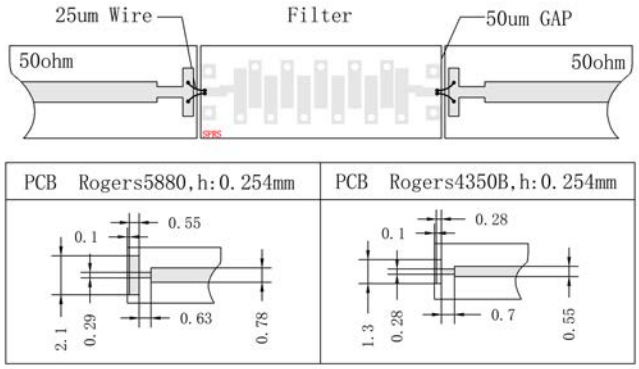
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

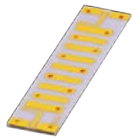
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

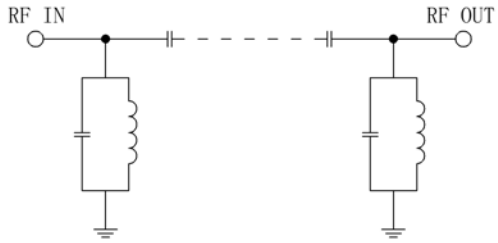
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

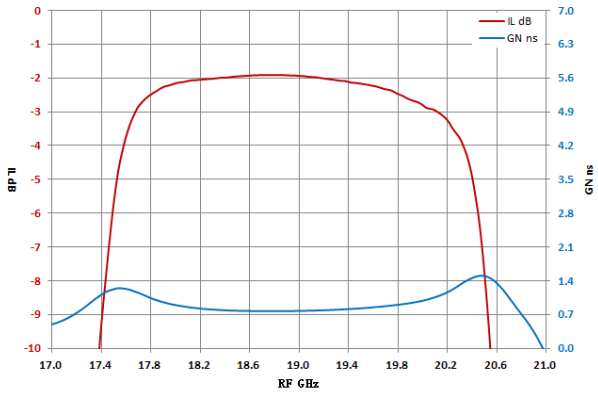
参考图

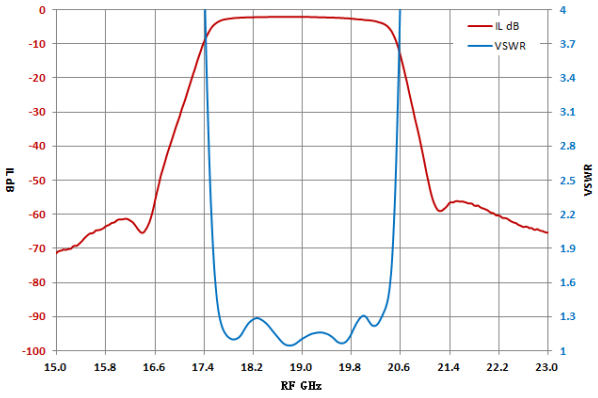


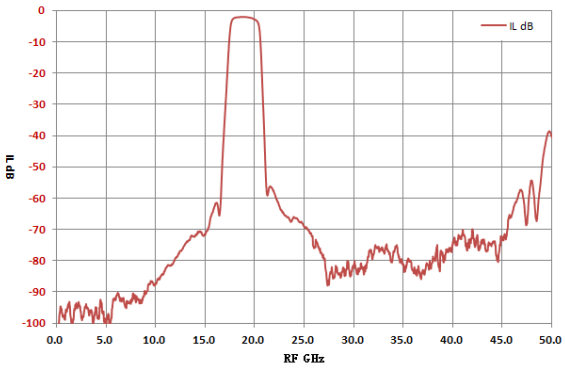
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

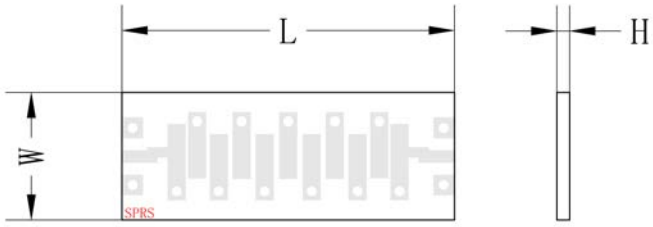
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	21.2	GHz
工作带宽	17.8-24.6	GHz
中心损耗	1.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-15.5GHz	dBc
带外抑制	40@26.6-45.0GHz	dBc

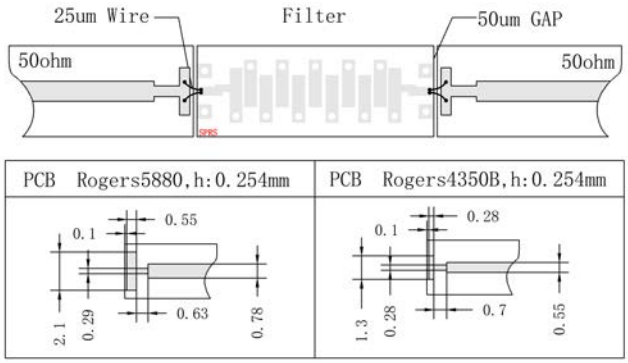
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



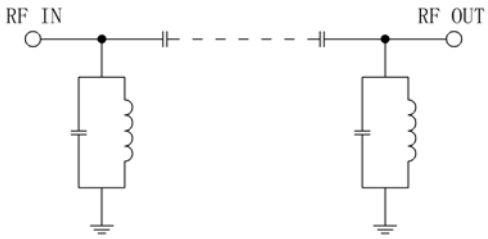
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

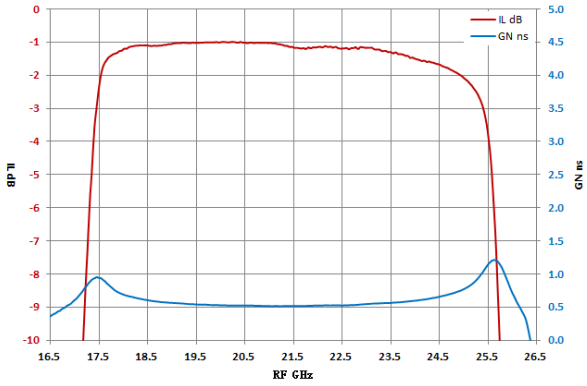
参考实物图

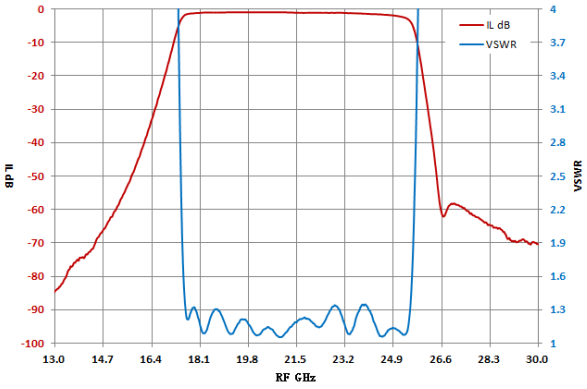


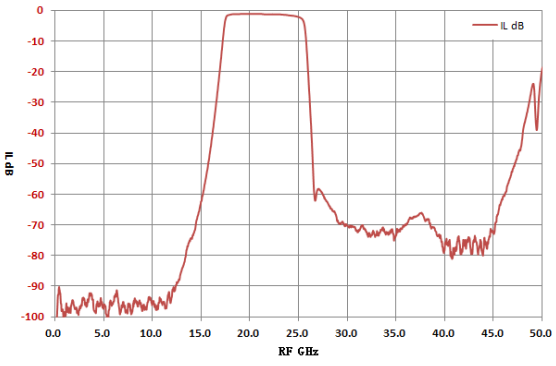
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

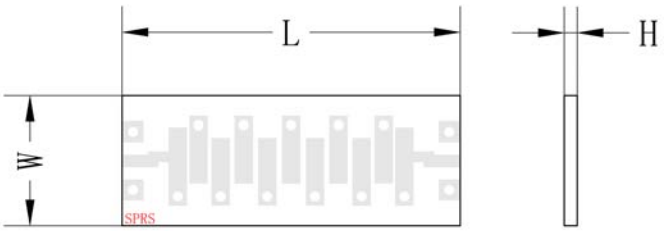
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	21.8	GHz
工作带宽	17.8-25.8	GHz
中心损耗	1.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-14.2GHz	dBc
带外抑制	40@28.9-49.0GHz	dBc

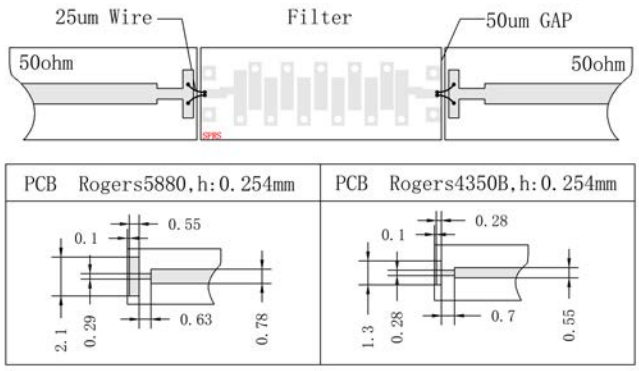
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：6.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

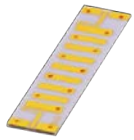
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

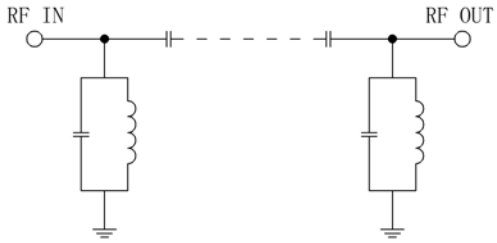
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

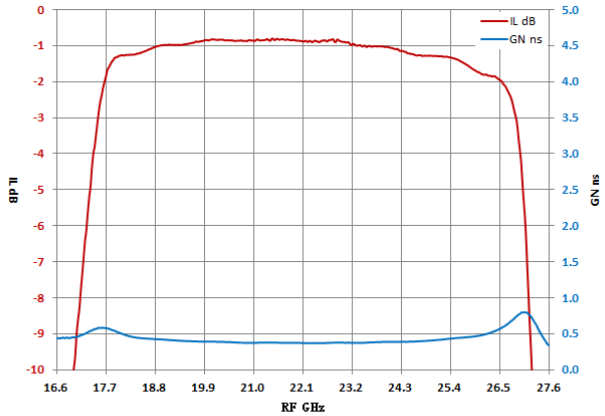
参考图

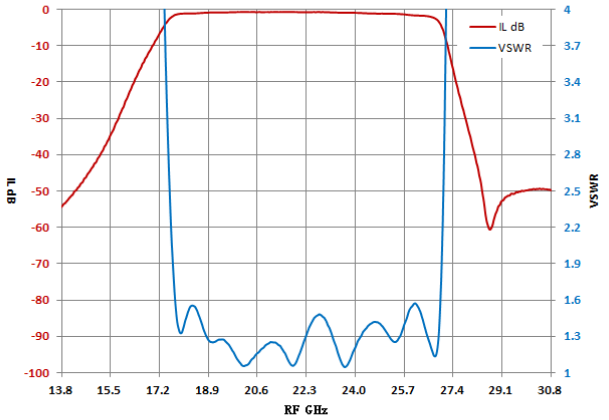


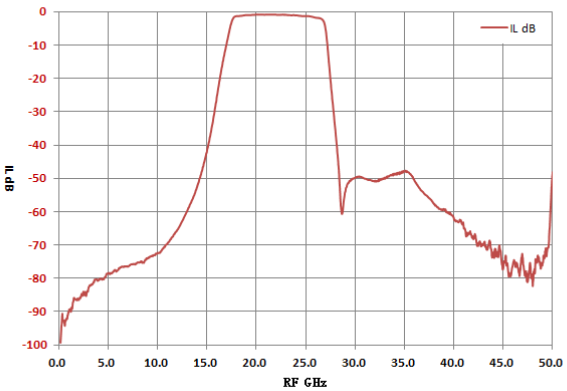
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

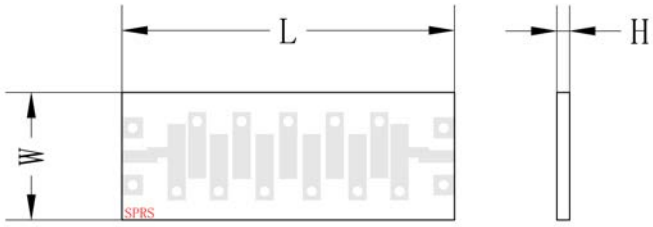
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	22.1	GHz
工作带宽	17.8-26.4	GHz
中心损耗	1.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-14.3GHz	dBc
带外抑制	40@30.0-32.0GHz	dBc

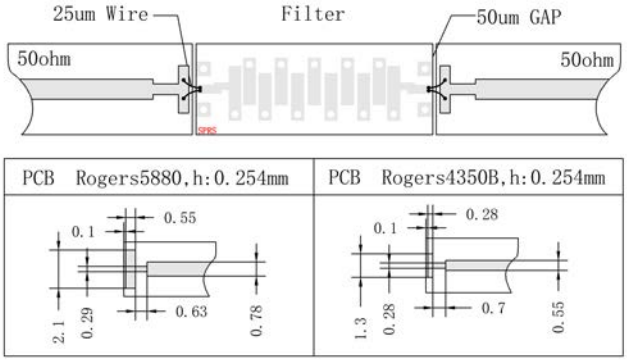
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



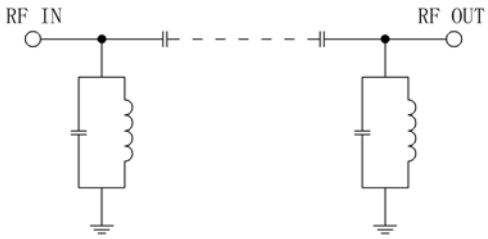
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

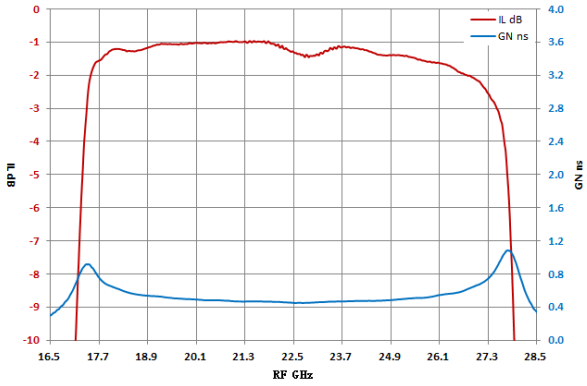
参考实物图

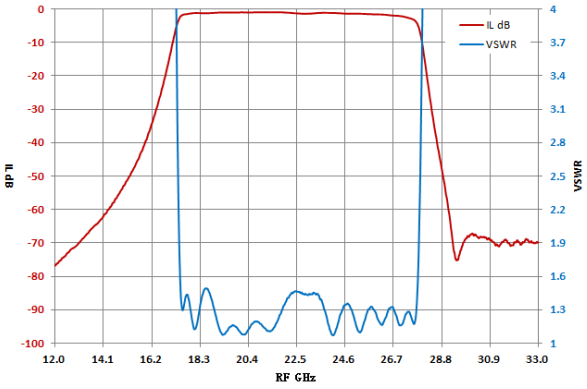


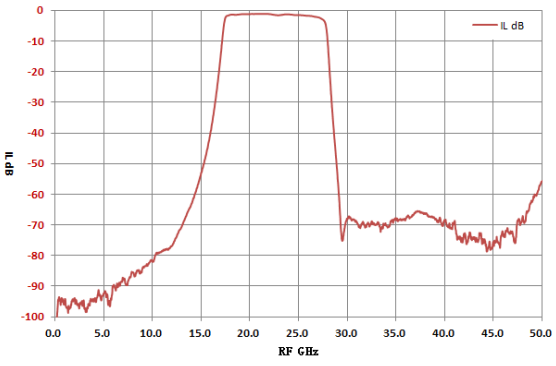
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



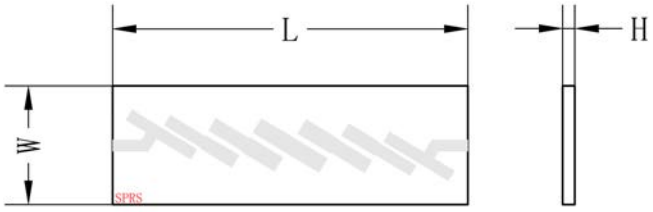
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	17.9	GHz
工作带宽	0	GHz
中心损耗	4.5	dB
带内波动	0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0	ns
带外抑制	40@DC-16.7GHz	dBc
带外抑制	40@19.1-28.0GHz	dBc

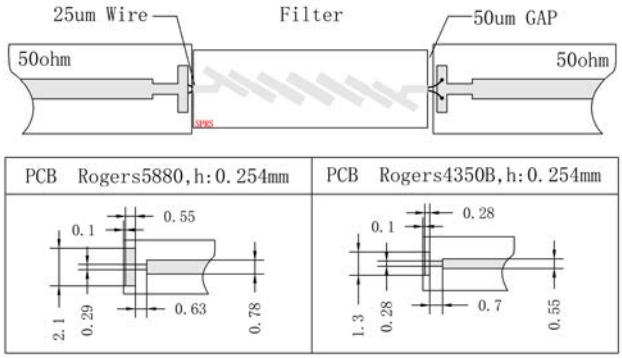
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：5.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



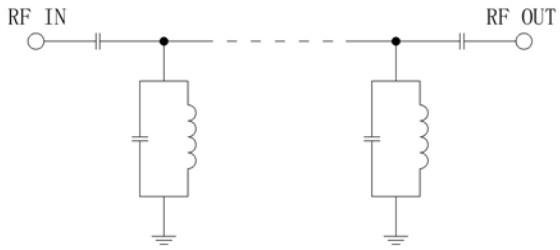
推荐装配图



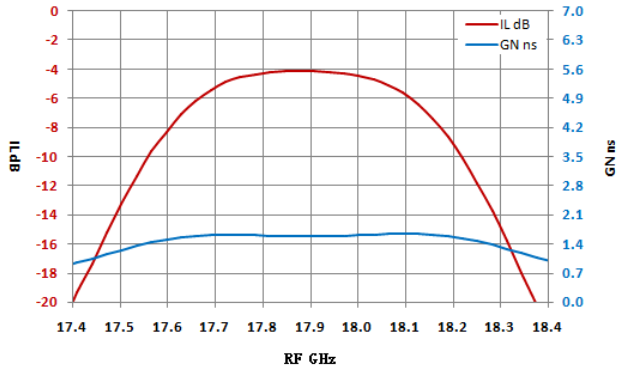
注意事项

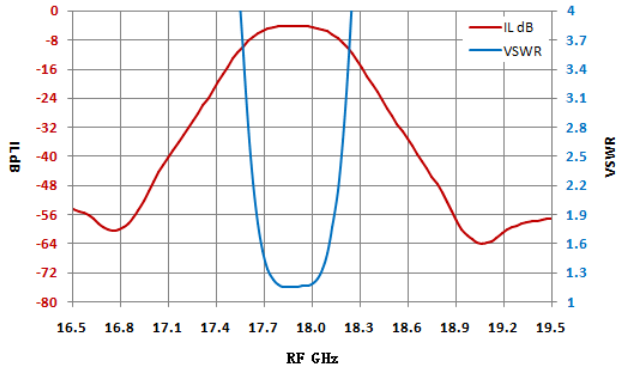
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

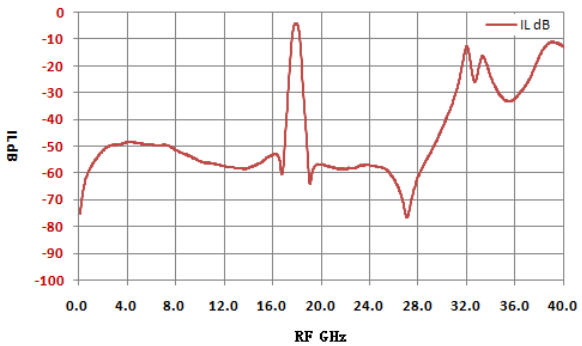
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

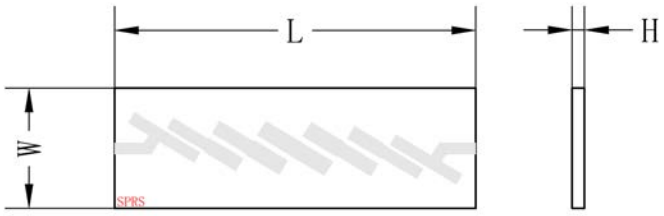
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	18.0	GHz
工作带宽	17.9-18.1	GHz
中心损耗	4.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-16.5GHz	dBc
带外抑制	40@19.8-30.0GHz	dBc

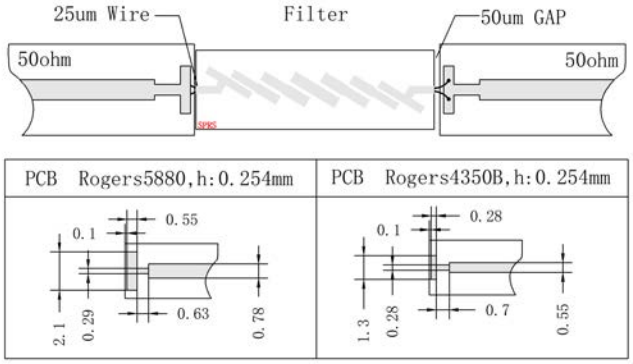
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：4.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

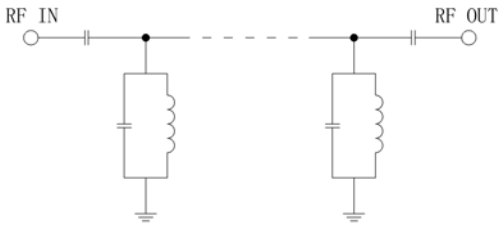
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

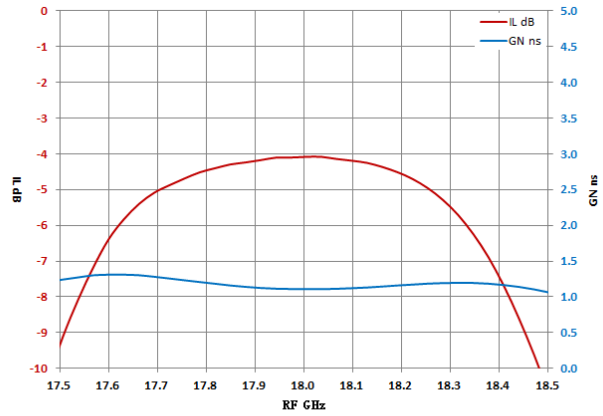
参考图

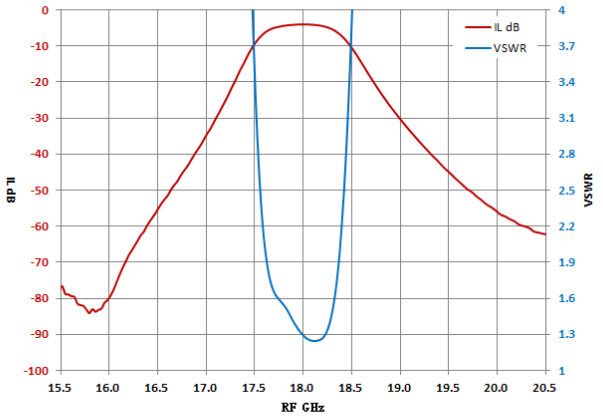


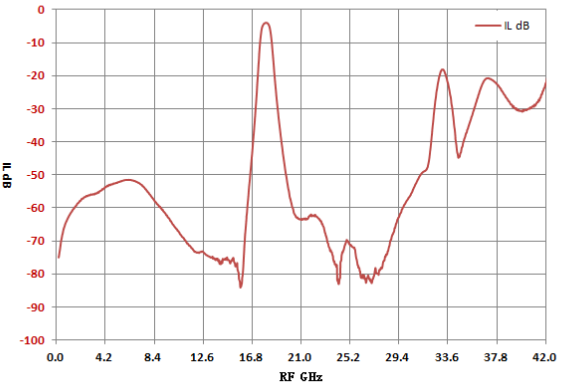
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

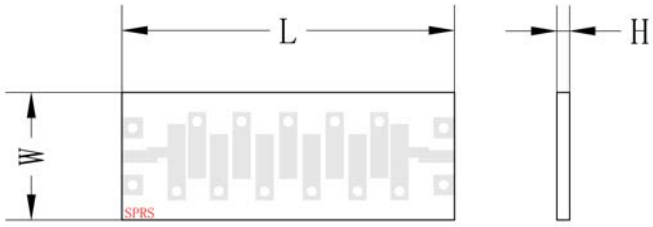
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	18.85	GHz
工作带宽	17.9-19.8	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-16.3GHz	dBc
带外抑制	40@21.9-40.0GHz	dBc

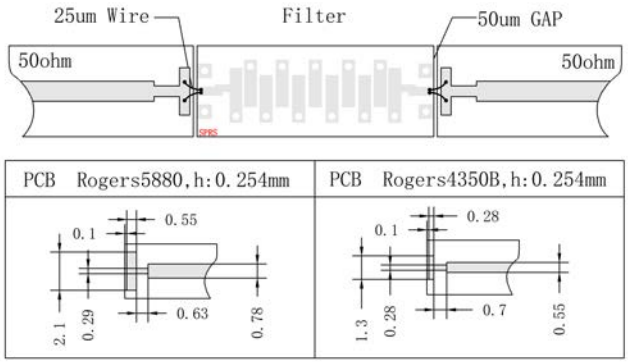
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



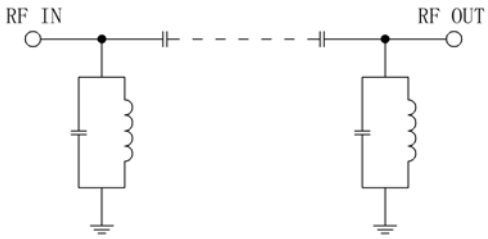
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

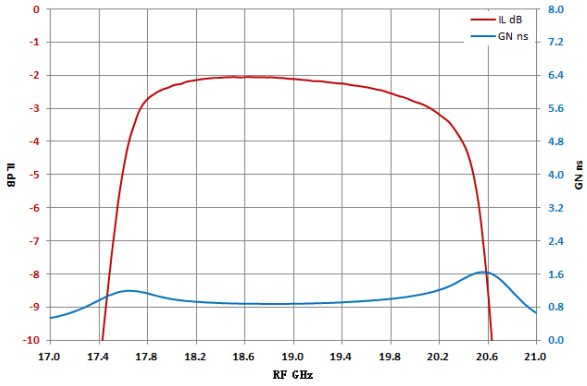
参考实物图

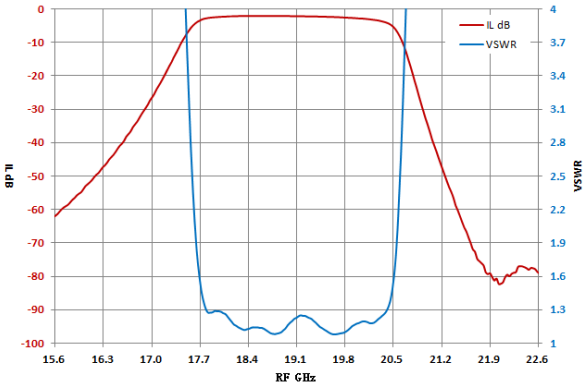


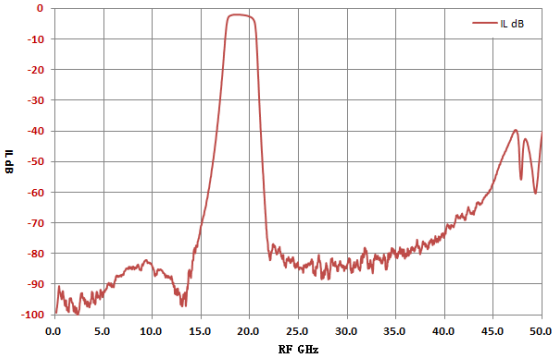
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

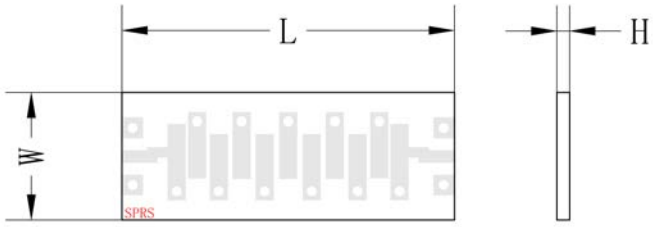
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	19.55	GHz
工作带宽	17.9-21.2	GHz
中心损耗	1.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-16.3GHz	dBc
带外抑制	40@22.9-43.0GHz	dBc

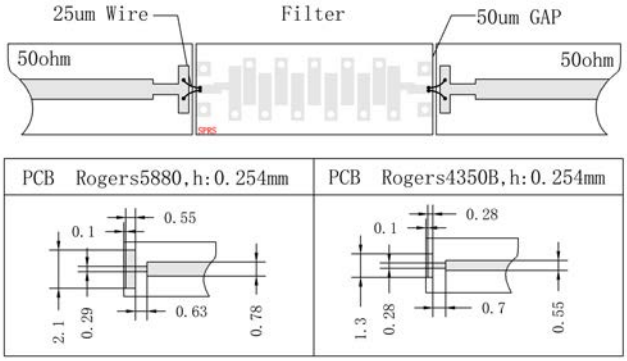
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



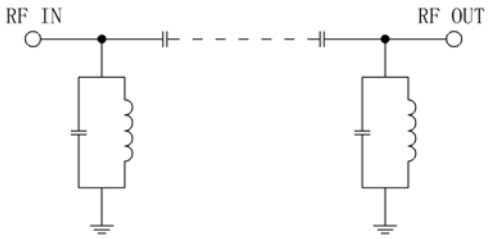
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

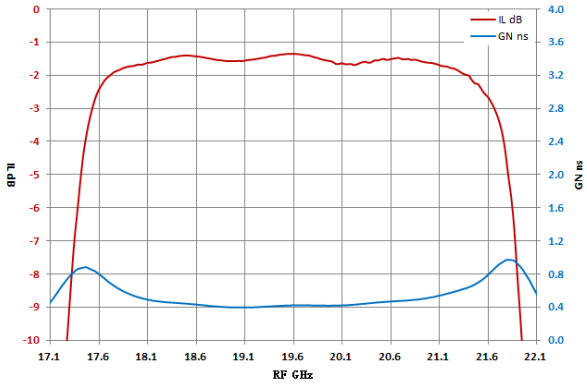
参考实物图

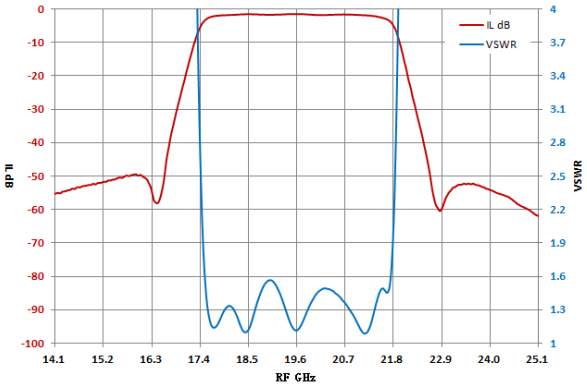


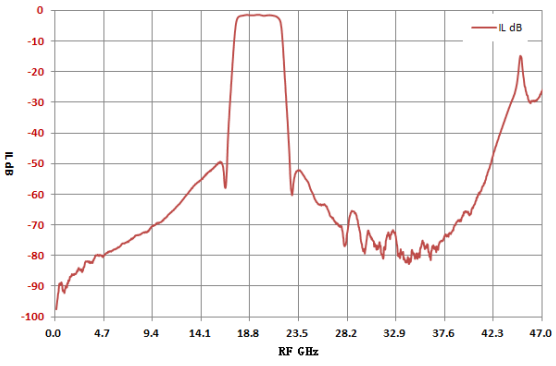
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

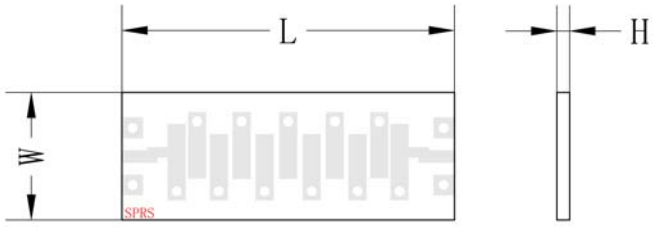
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	20.0	GHz
工作带宽	17.9-22.1	GHz
中心损耗	1.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-15.8GHz	dBc
带外抑制	40@24.6-44.0GHz	dBc

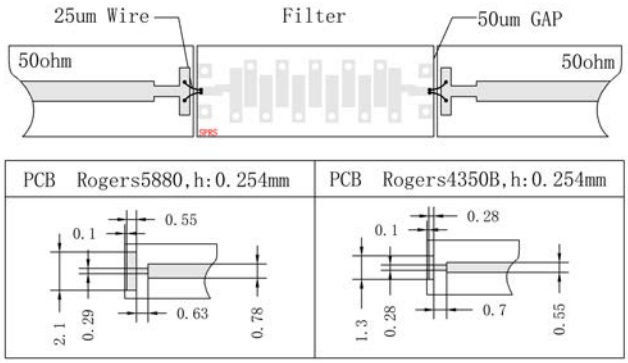
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



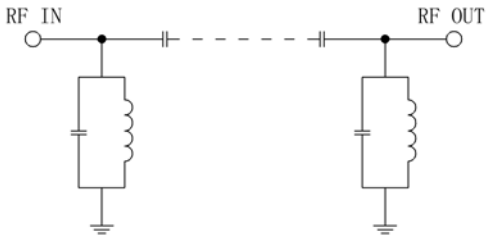
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.74mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

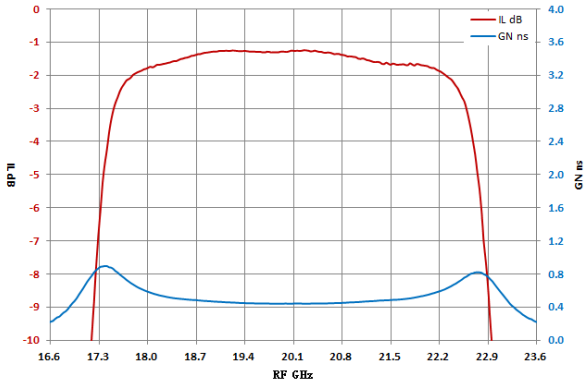
参考实物图

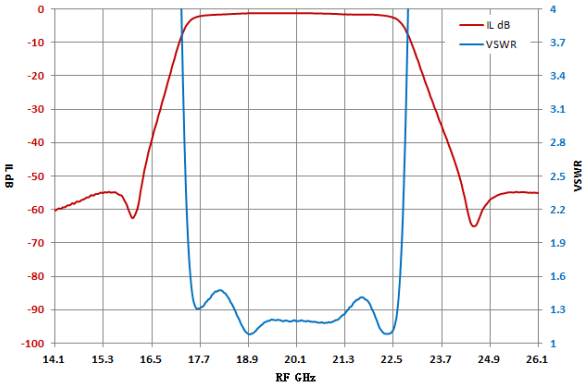


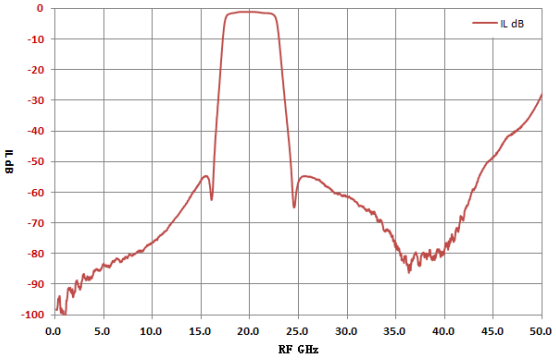
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

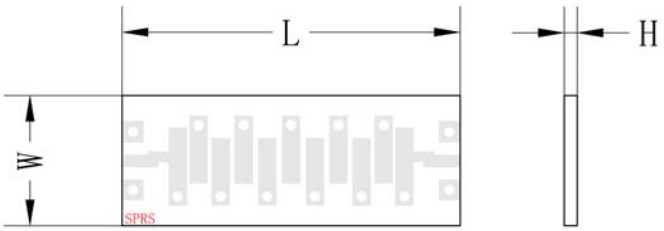
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	18.7	GHz
工作带宽	18.0-19.4	GHz
中心损耗	3.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-16.3GHz	dBc
带外抑制	50@20.8-44.0GHz	dBc

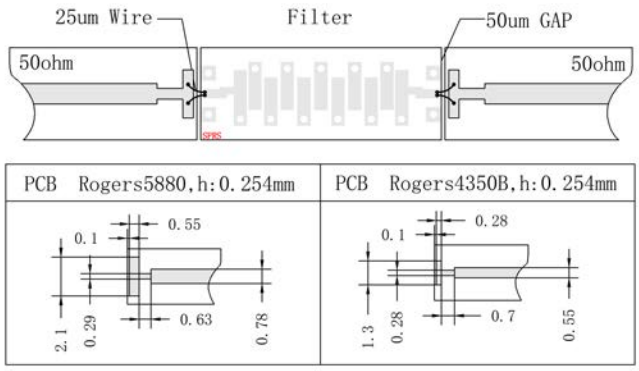
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.74mm,端口可互换;

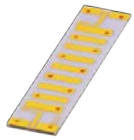
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

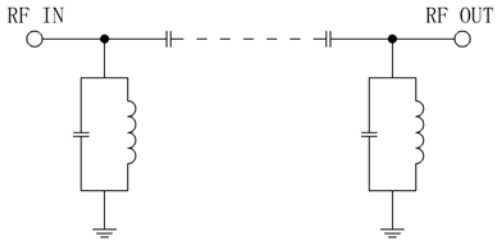
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

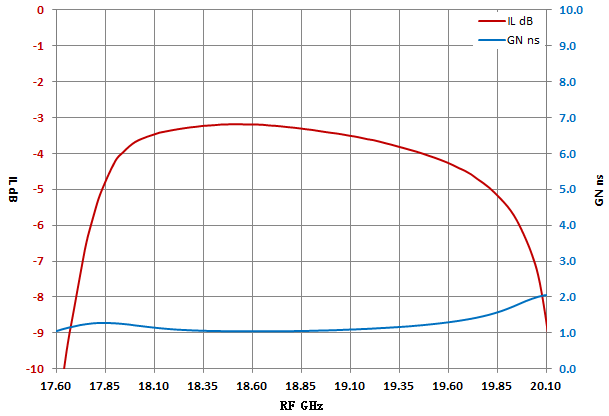
参考图

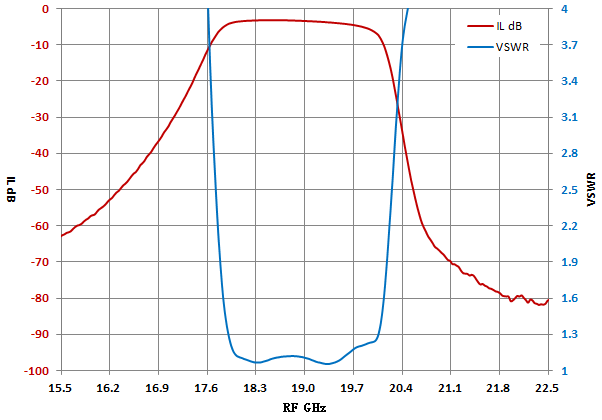


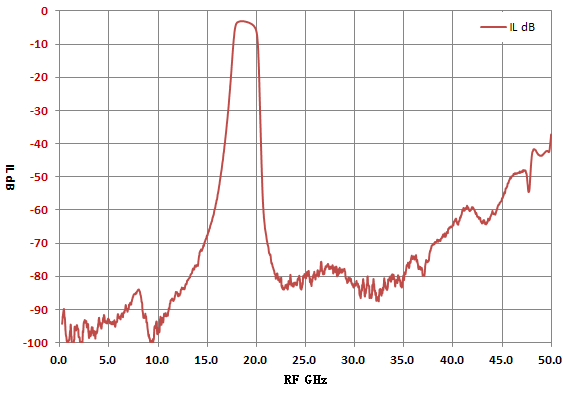
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

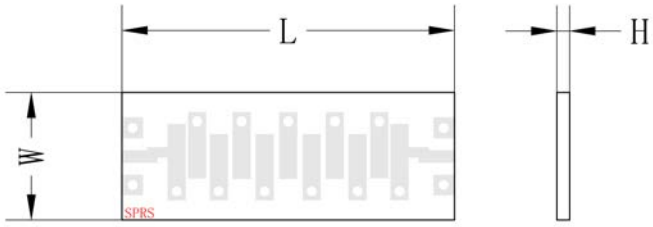
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	18.9	GHz
工作带宽	18.0-19.8	GHz
中心损耗	2.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-16.7GHz	dBc
带外抑制	40@21.3-42.0GHz	dBc

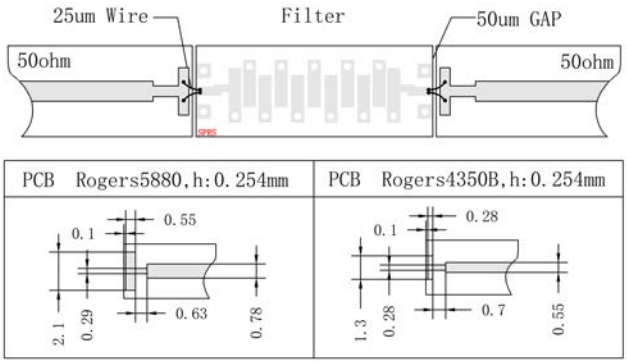
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



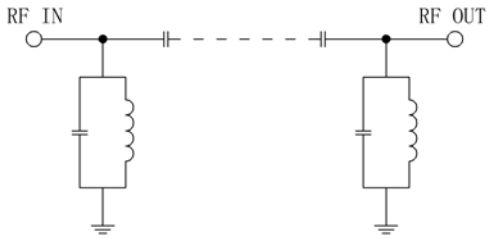
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

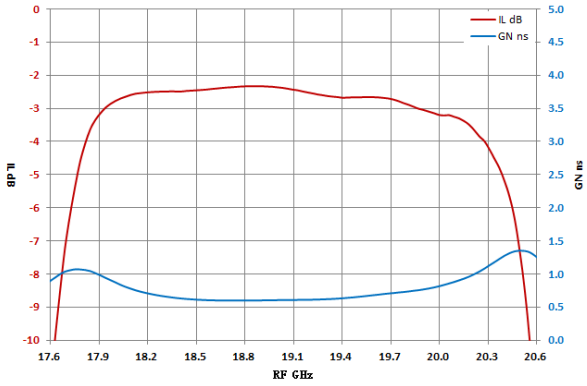
参考实物图

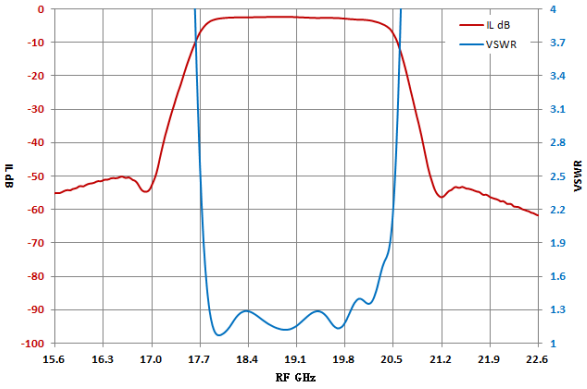


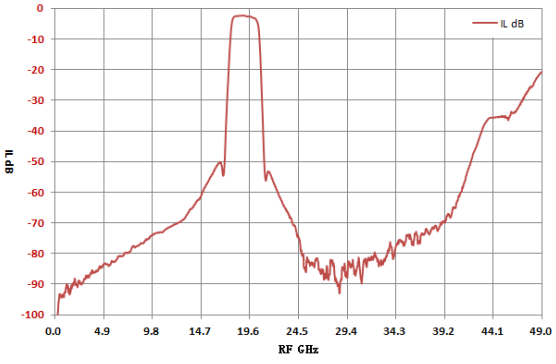
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



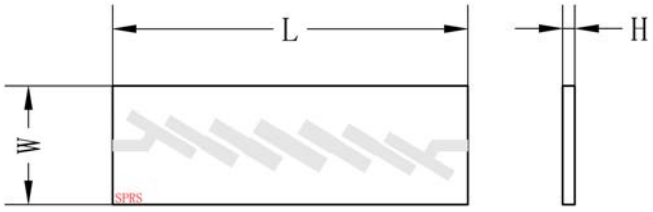
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	19.1	GHz
工作带宽	18.0-20.2	GHz
中心损耗	2.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-16.6GHz	dBc
带外抑制	40@21.8-32.0GHz	dBc

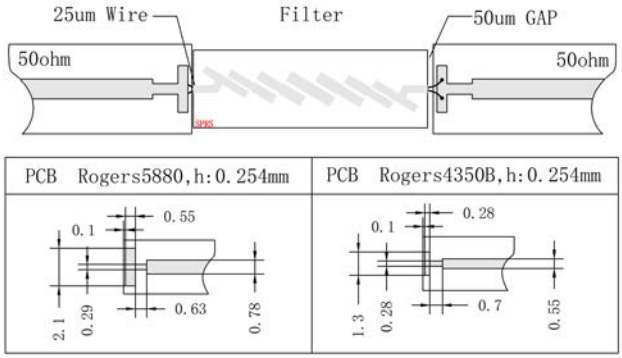
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：12.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



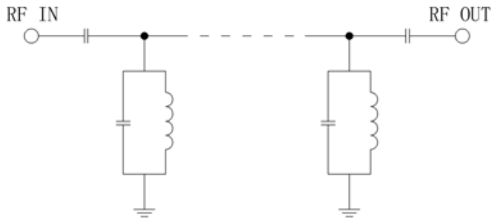
推荐装配图



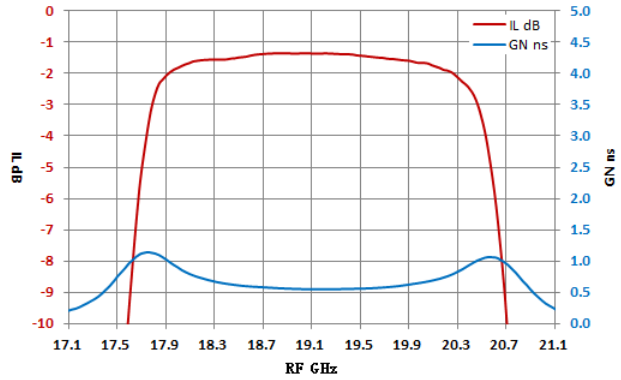
注意事项

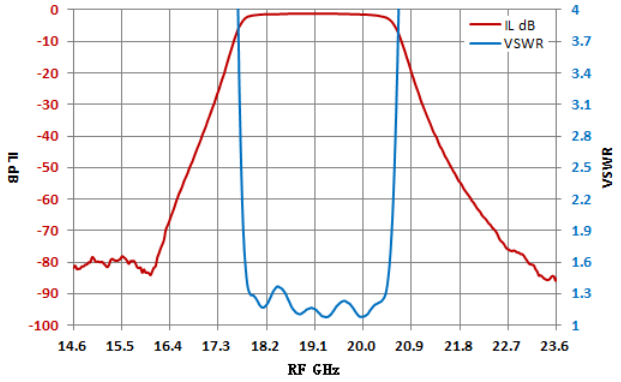
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

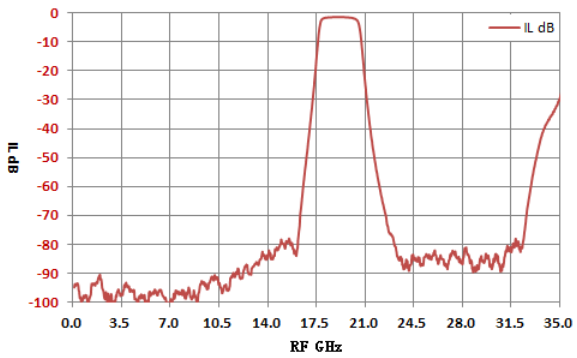
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



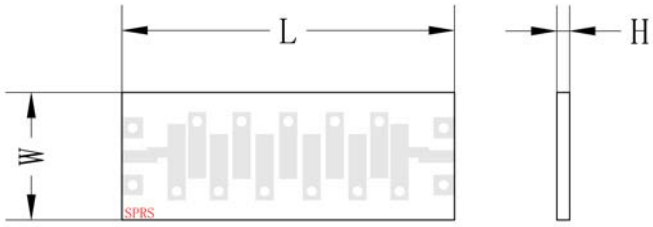
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	19.2	GHz
工作带宽	18.0-20.4	GHz
中心损耗	3.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-16.7GHz	dBc
带外抑制	40@22.0-47.0GHz	dBc

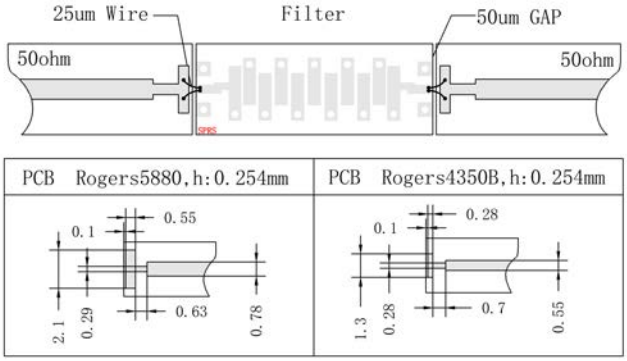
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



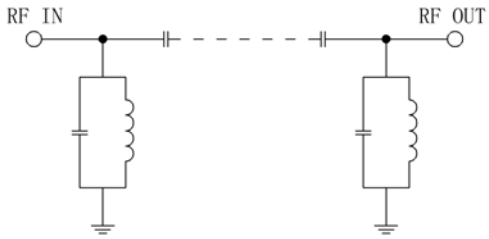
推荐装配图



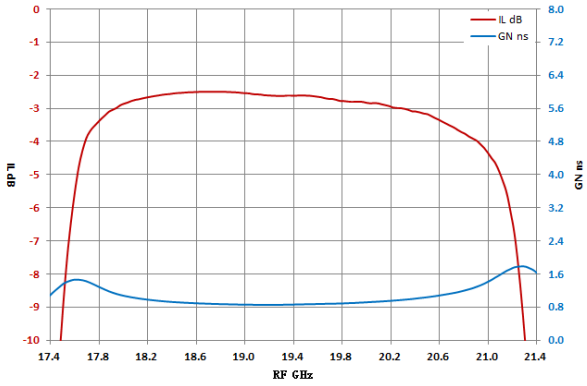
注意事项

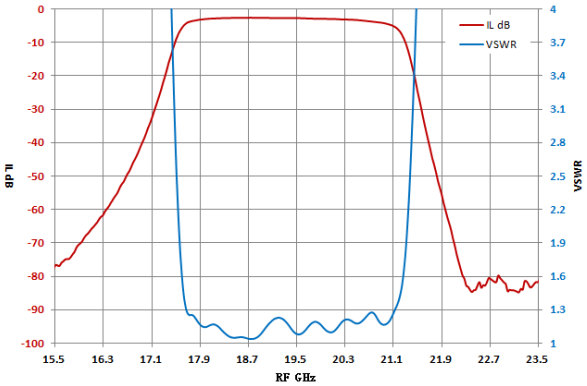
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

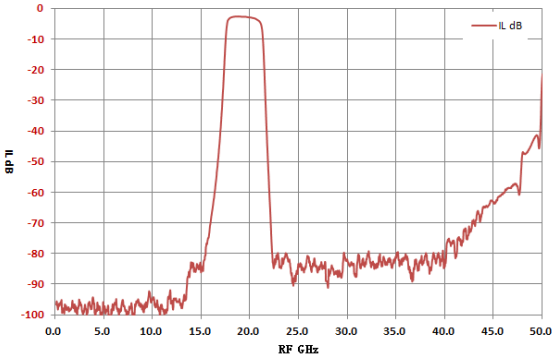
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



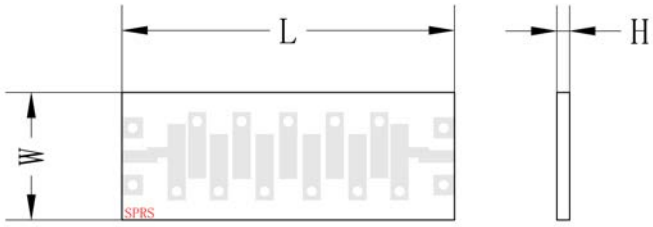
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	19.85	GHz
工作带宽	18.0-21.7	GHz
中心损耗	3.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-15.7GHz	dBc
带外抑制	40@24.8-45.0GHz	dBc

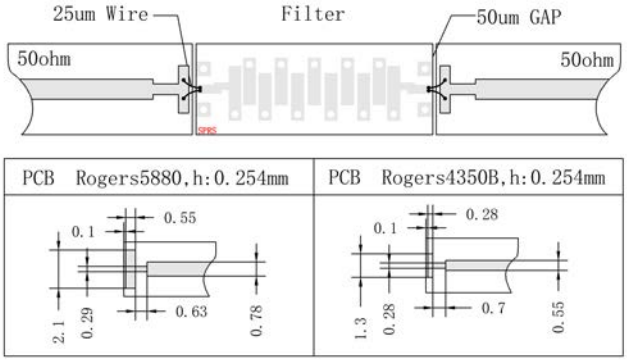
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



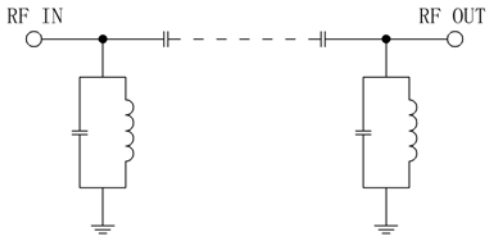
推荐装配图



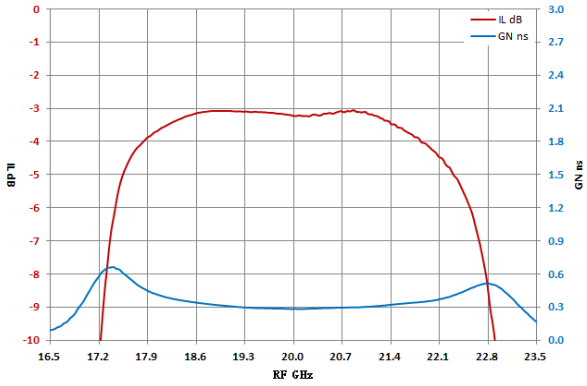
注意事项

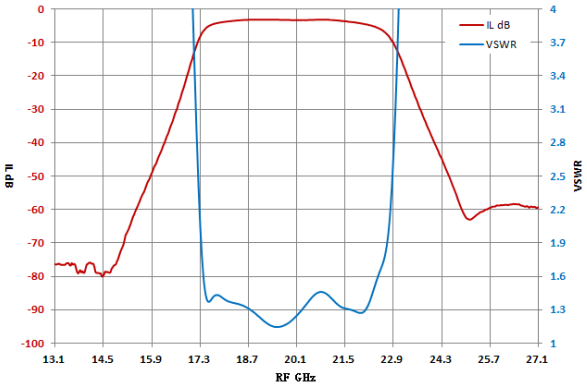
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

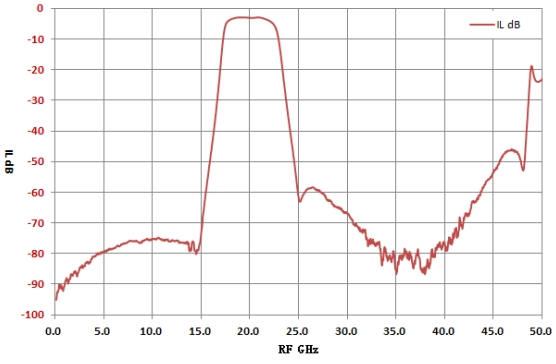
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



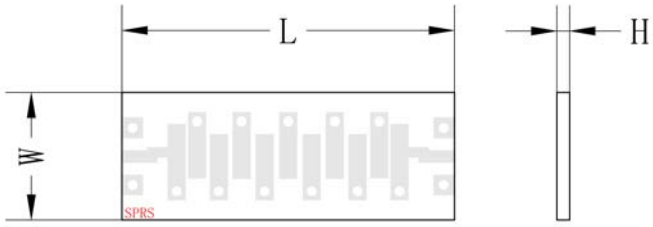
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	20.5	GHz
工作带宽	18.0-22.9	GHz
中心损耗	1.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-15.7GHz	dBc
带外抑制	40@25.5-43.0GHz	dBc

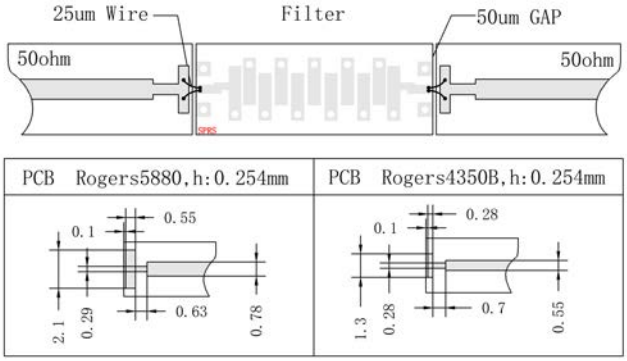
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



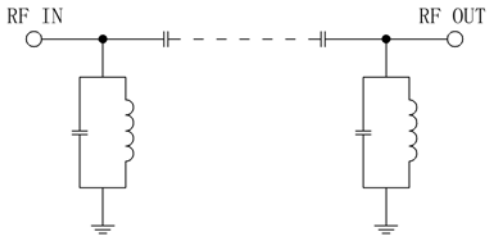
推荐装配图



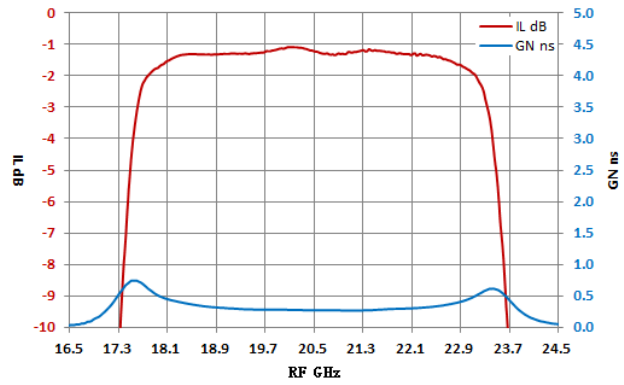
注意事项

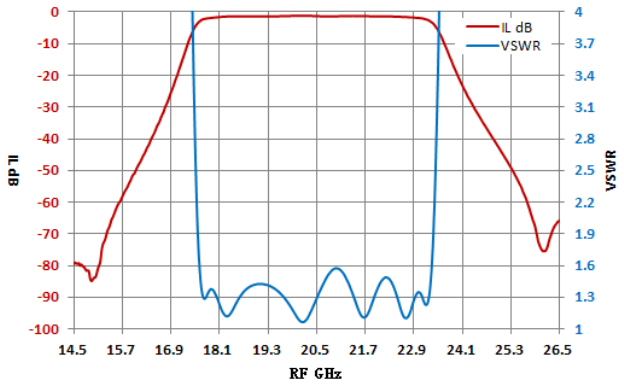
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

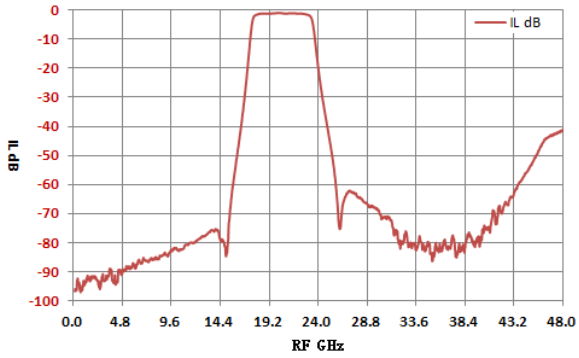
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



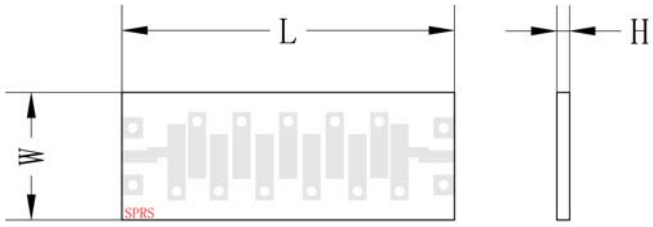
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	22.3	GHz
工作带宽	18.0-26.6	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-14.2GHz	dBc
带外抑制	40@29.6-50.0GHz	dBc

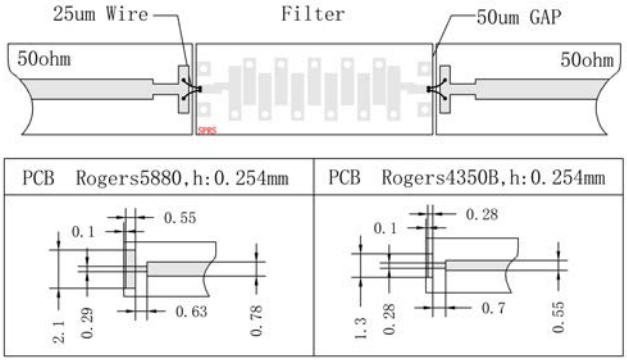
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



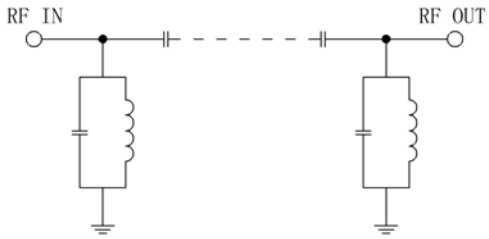
推荐装配图



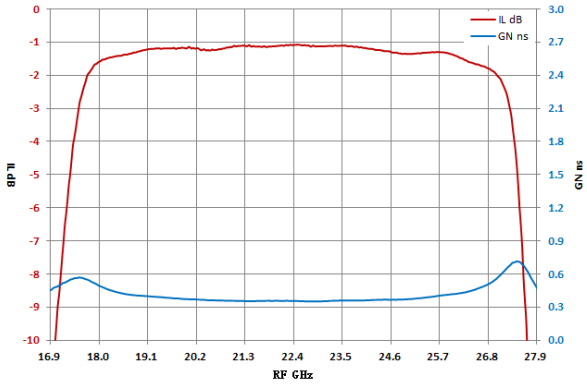
注意事项

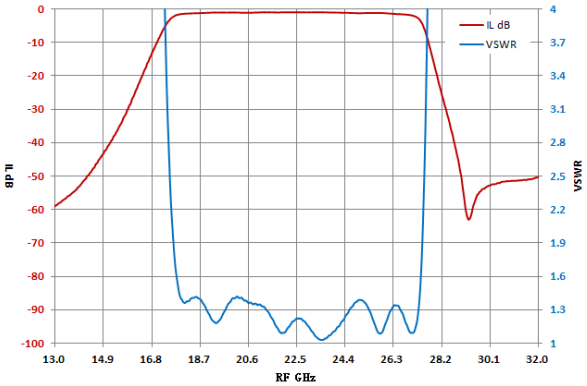
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

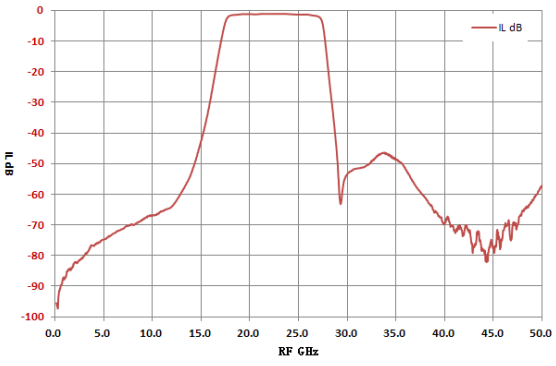
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

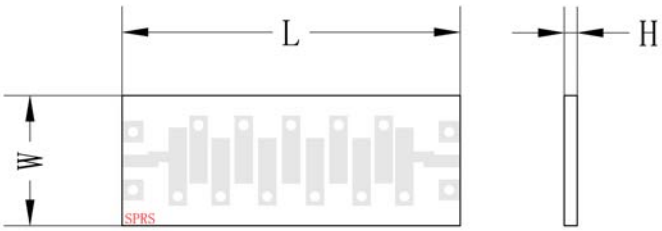
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	23.3	GHz
工作带宽	18.0-28.6	GHz
中心损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.8:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	45@DC-15.6GHz	dBc
带外抑制	40@32.2-50.0GHz	dBc

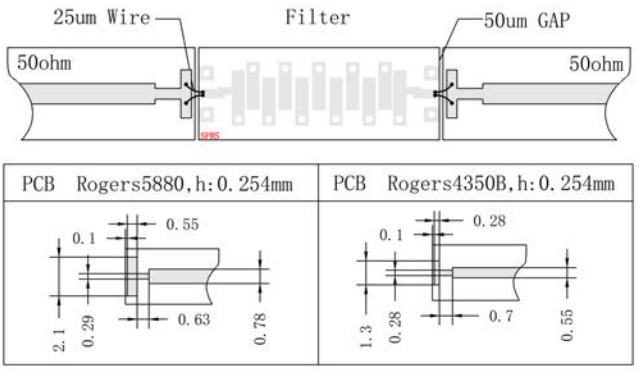
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：6.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

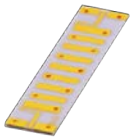
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

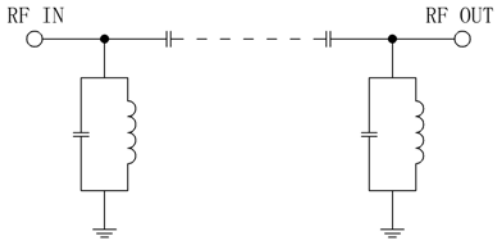
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

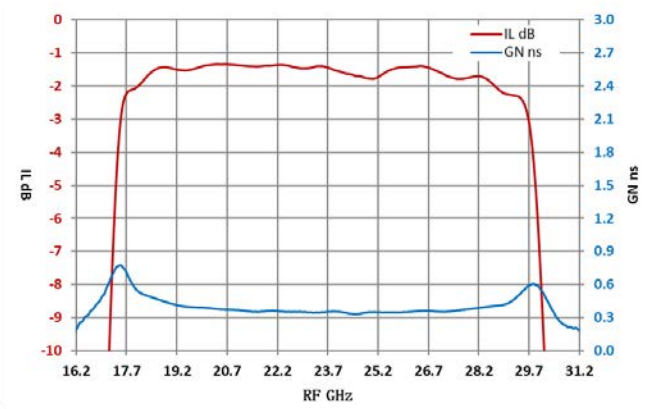
参考图

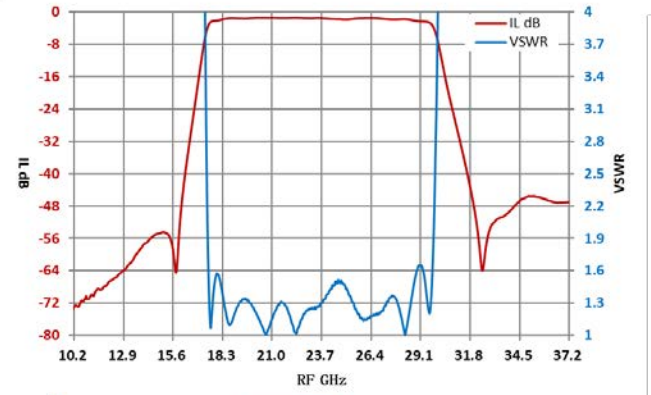


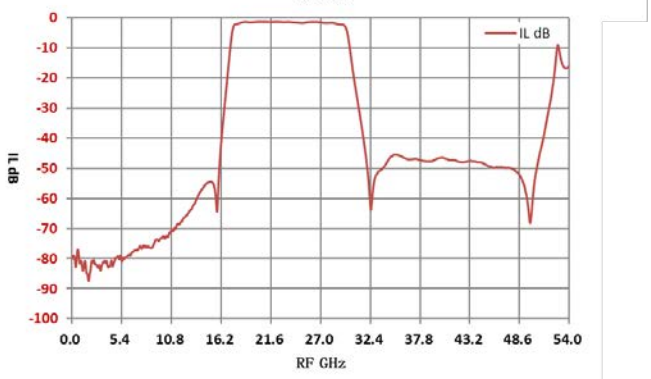
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

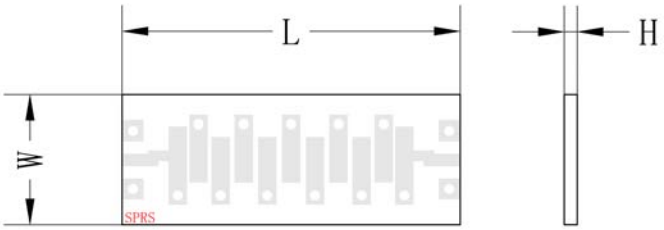
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	18.1	GHz
工作带宽	18.05-18.15	GHz
中心损耗	6.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-17.2GHz	dBc
带外抑制	40@18.8-47.0GHz	dBc

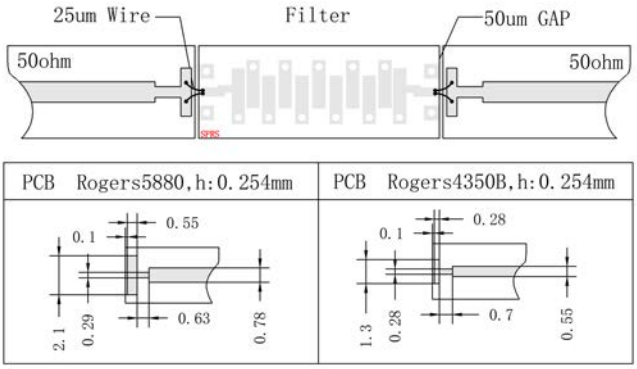
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：8.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

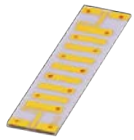
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

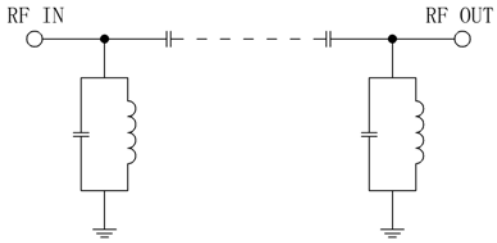
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

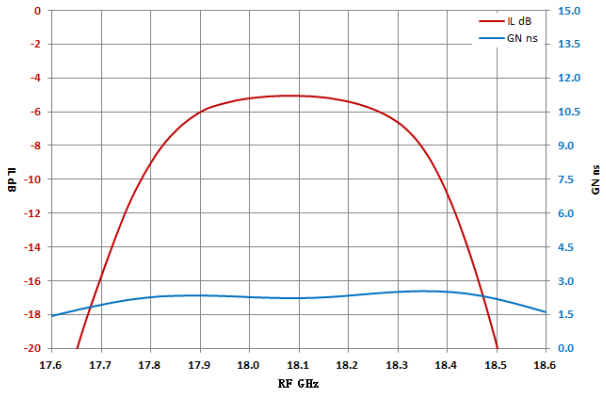
参考图

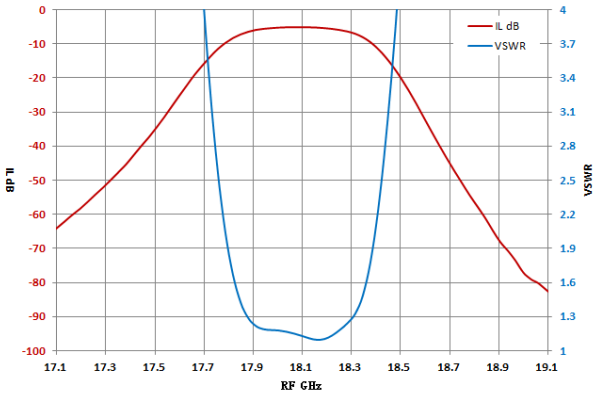


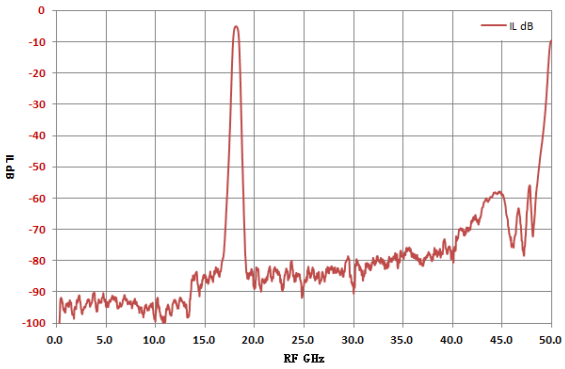
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



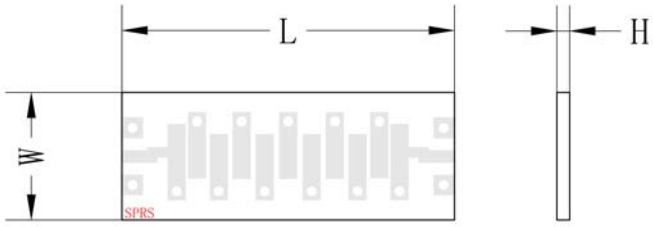
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	19.9	GHz
工作带宽	18.2-21.6	GHz
中心损耗	2.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	30@DC-16.8GHz	dBc
带外抑制	40@23.6-45.0GHz	dBc

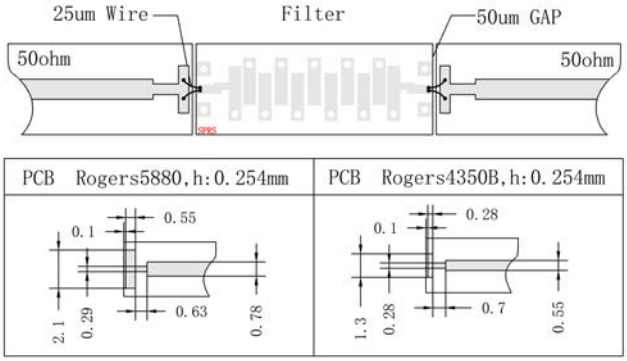
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



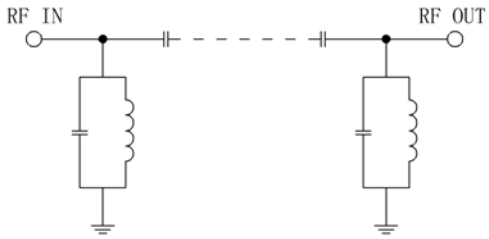
推荐装配图



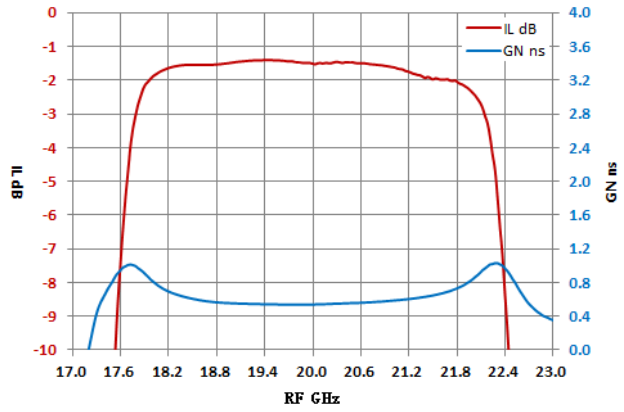
注意事项

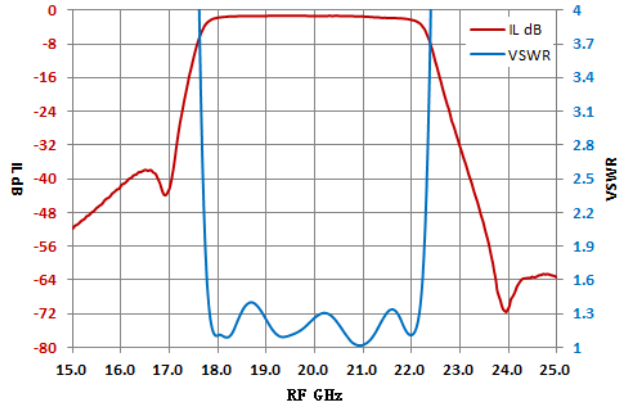
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

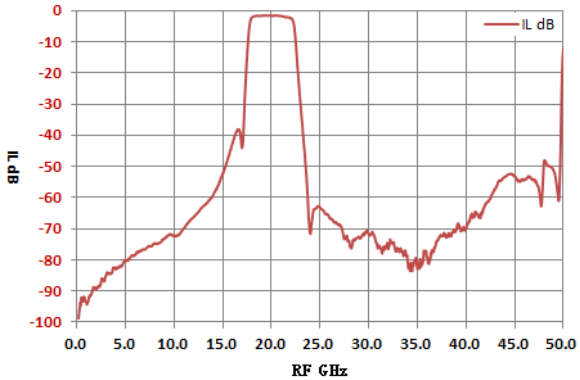
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



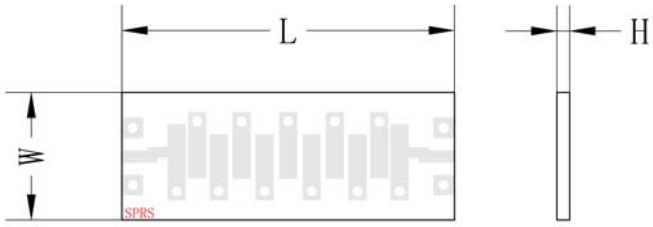
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	21.2	GHz
工作带宽	18.2-24.2	GHz
中心损耗	2.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-16.0GHz	dBc
带外抑制	40@26.5-44.0GHz	dBc

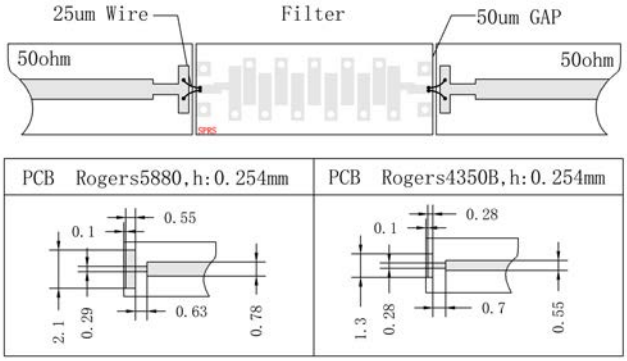
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



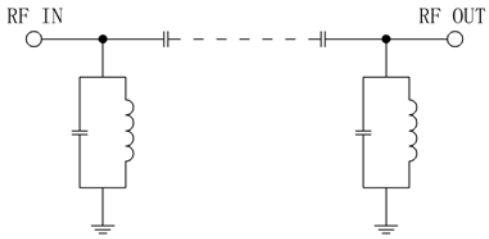
推荐装配图



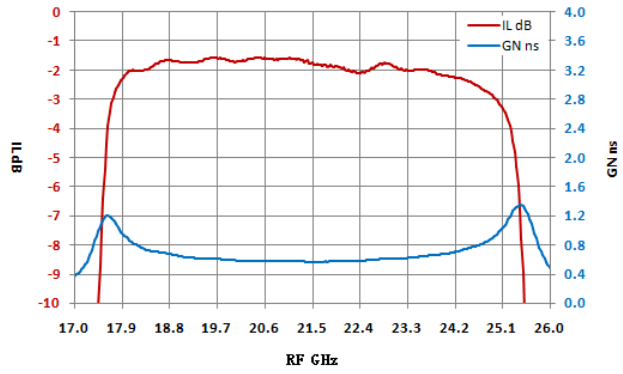
注意事项

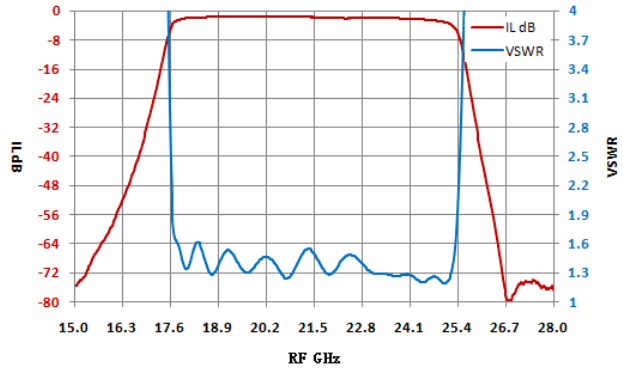
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

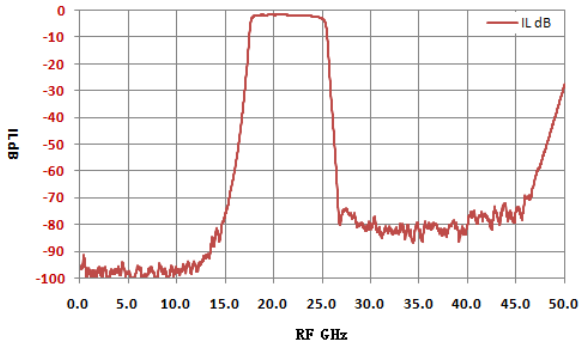
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



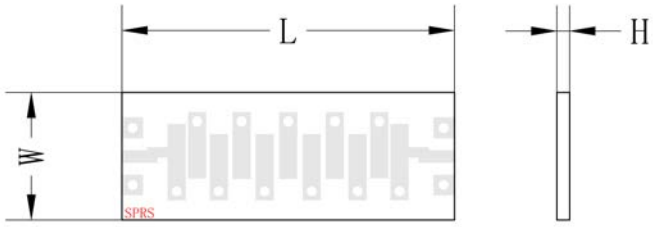
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	21.3	GHz
工作带宽	18.2-24.4	GHz
中心损耗	2.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-16.2GHz	dBc
带外抑制	40@26.6-45.0GHz	dBc

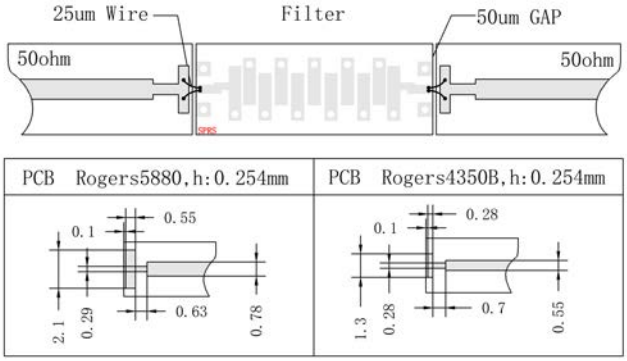
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



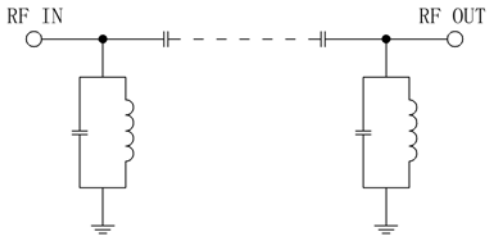
推荐装配图



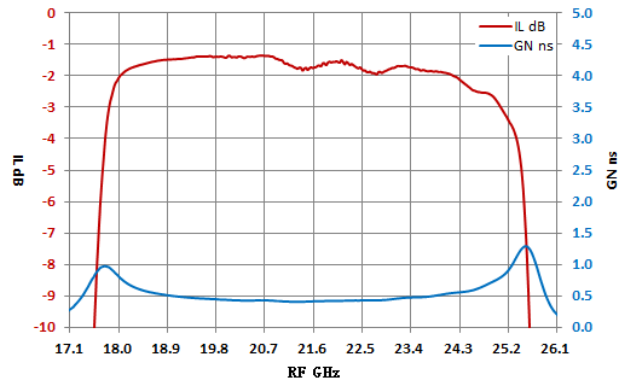
注意事项

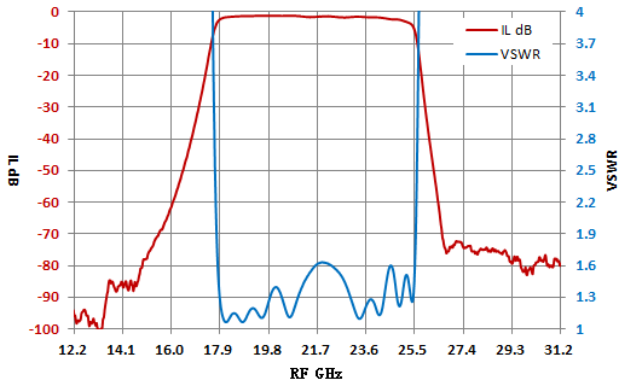
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

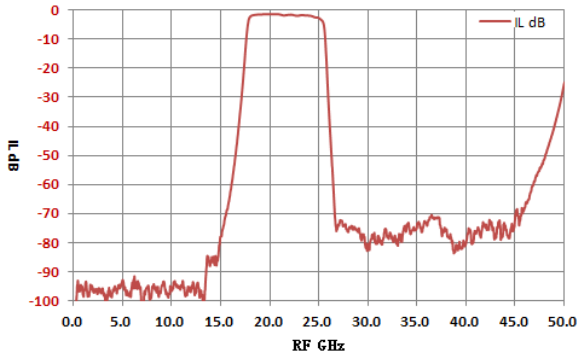
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



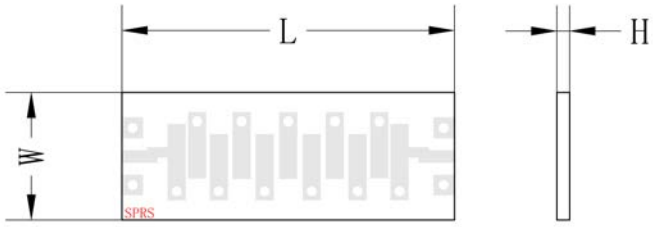
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	19.8	GHz
工作带宽	18.3-21.2	GHz
中心损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-16.6GHz	dBc
带外抑制	40@22.7-40.0GHz	dBc

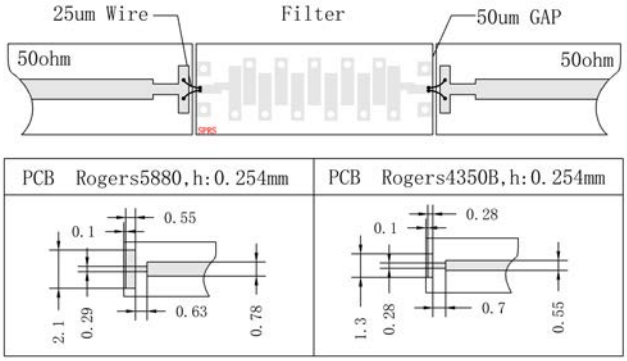
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



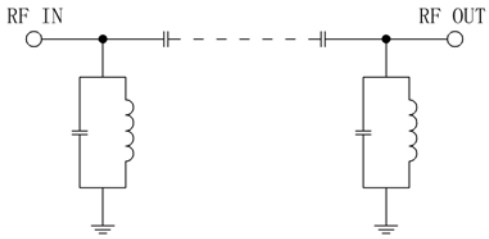
推荐装配图



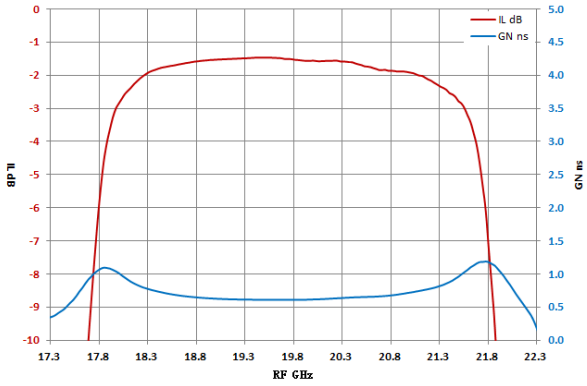
注意事项

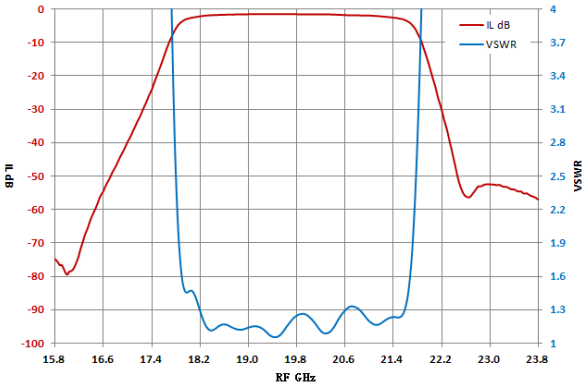
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

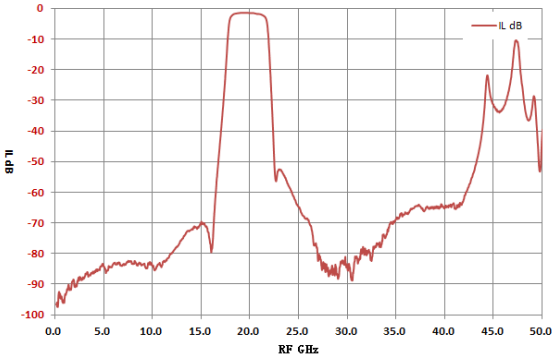
原理图



典型曲线







陶瓷滤波器 STBP220-7R2-K599

工作带宽 18.4-25.6GHz,带外抑制 40@DC-15.5GHz,40@28.6-45.0GHz

产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



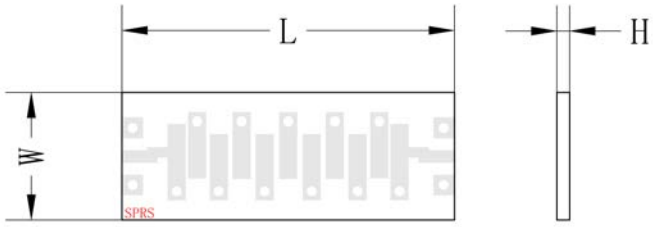
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	22.0	GHz
工作带宽	18.4-25.6	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-15.5GHz	dBc
带外抑制	40@28.6-45.0GHz	dBc

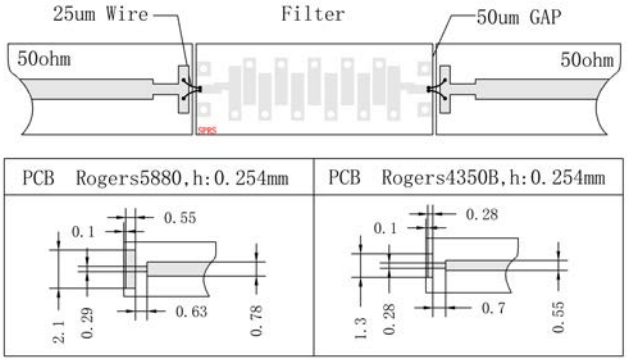
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



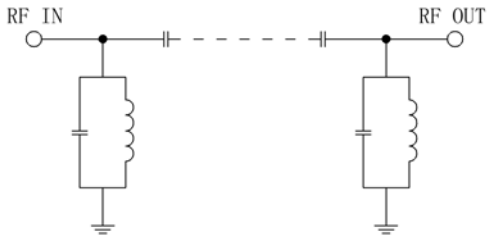
推荐装配图



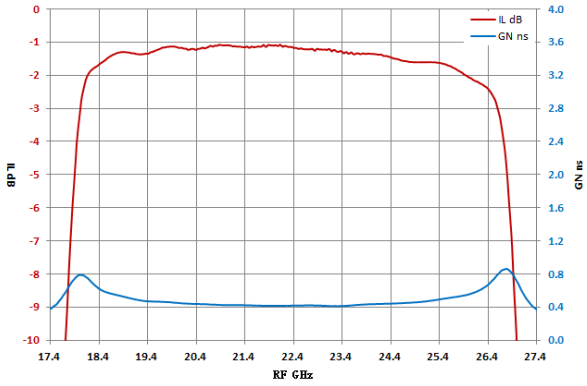
注意事项

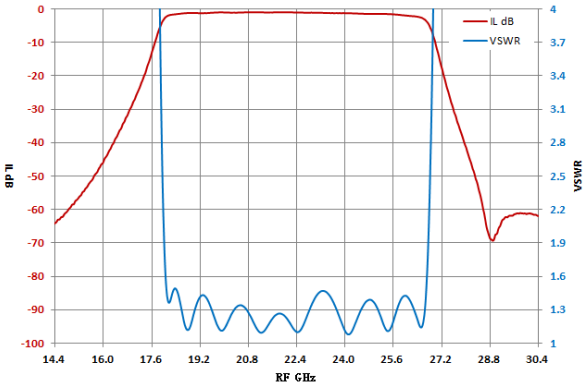
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

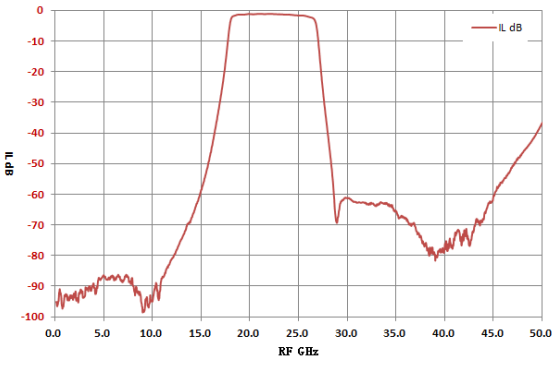
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



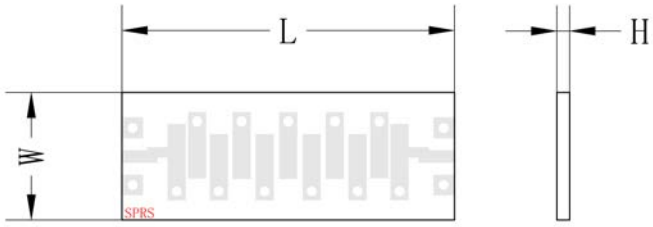
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	18.6	GHz
工作带宽	18.5-18.7	GHz
中心损耗	3.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-17.4GHz	dBc
带外抑制	40@20.0-40.0GHz	dBc

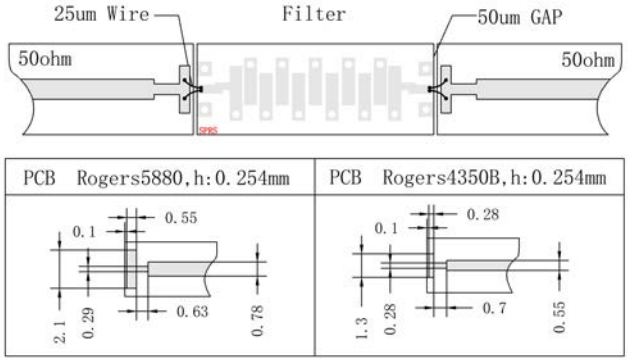
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：4.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



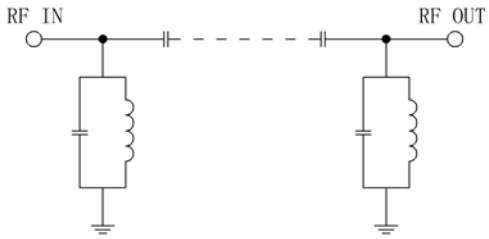
推荐装配图



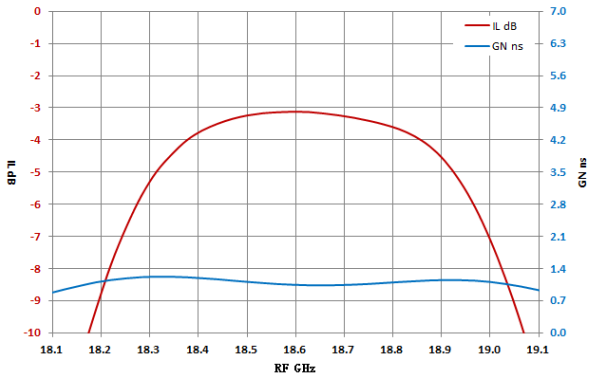
注意事项

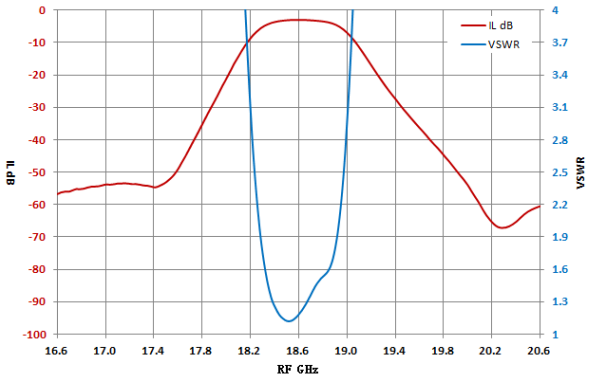
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

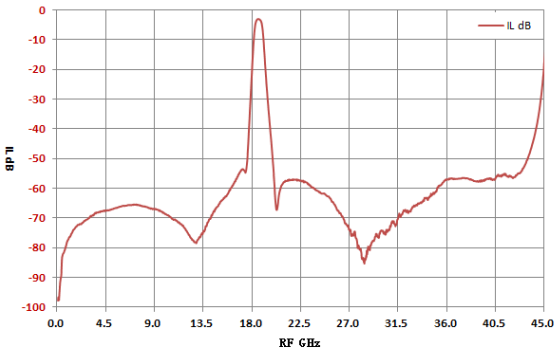
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

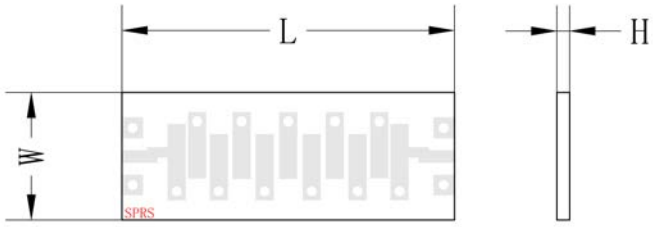
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	22.5	GHz
工作带宽	18.5-26.5	GHz
中心损耗	1.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-14.5GHz	dBc
带外抑制	40@29.5-43.0GHz	dBc

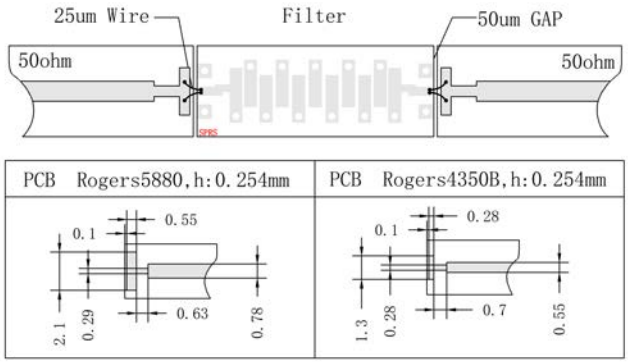
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



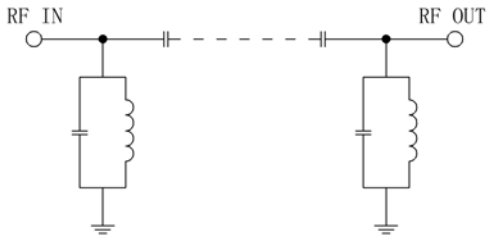
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.87mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

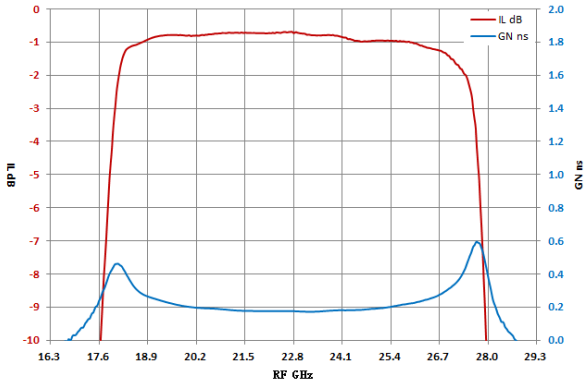
参考实物图

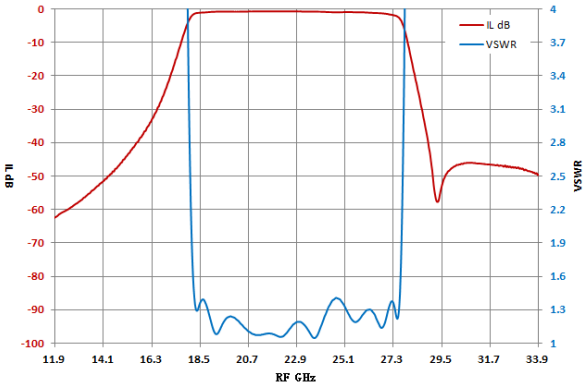


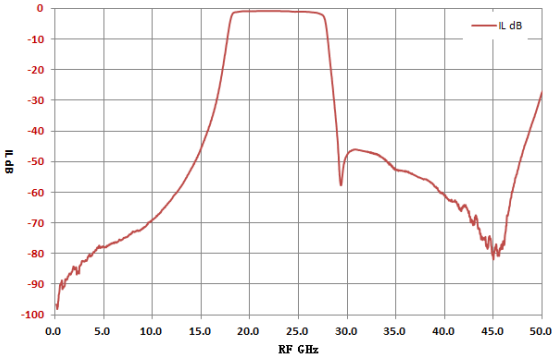
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



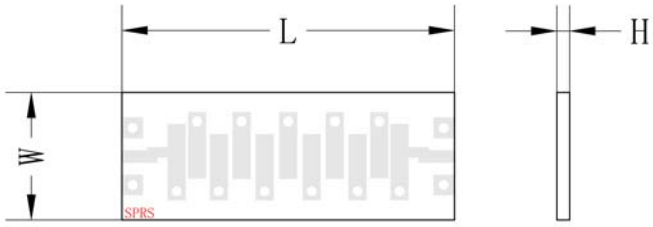
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	20.6	GHz
工作带宽	18.6-22.6	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-15.0GHz	dBc
带外抑制	40@24.4-45.0GHz	dBc

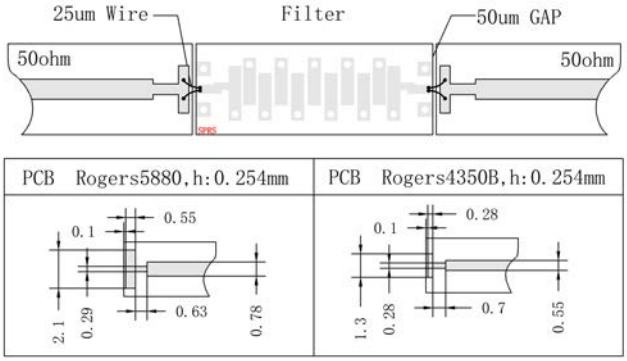
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：5.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



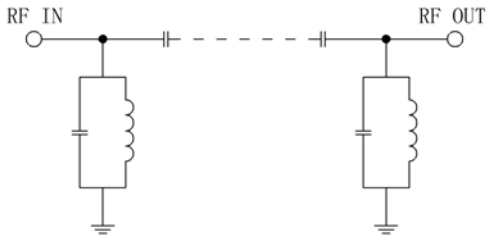
推荐装配图



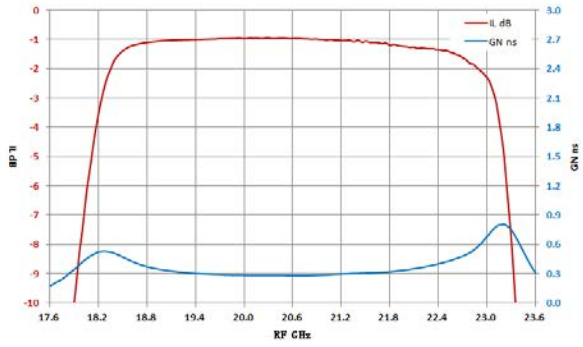
注意事项

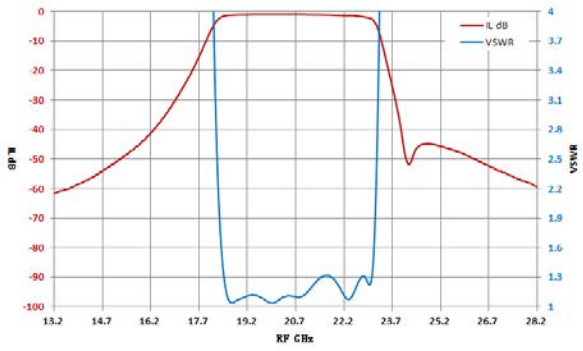
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

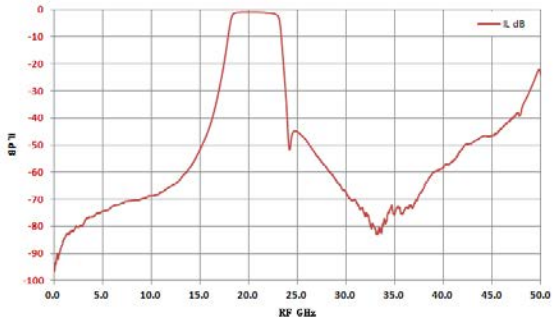
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



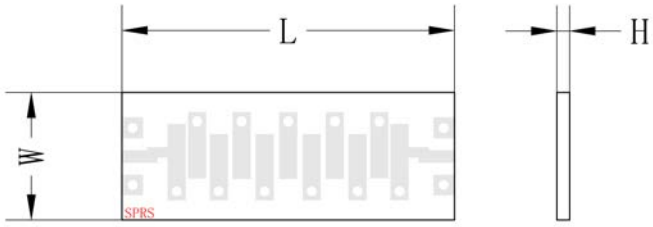
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	20.6	GHz
工作带宽	18.8-22.4	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-17.2GHz	dBc
带外抑制	40@24.0-40.0GHz	dBc

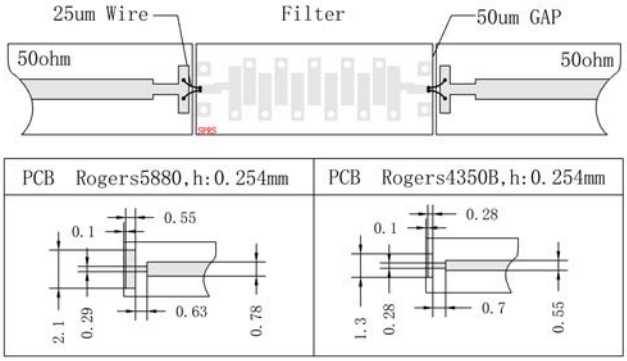
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



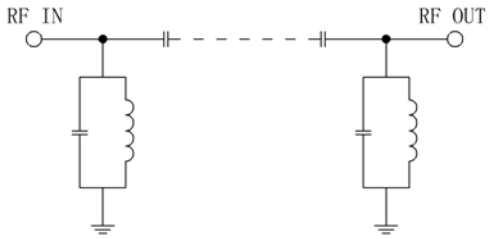
推荐装配图



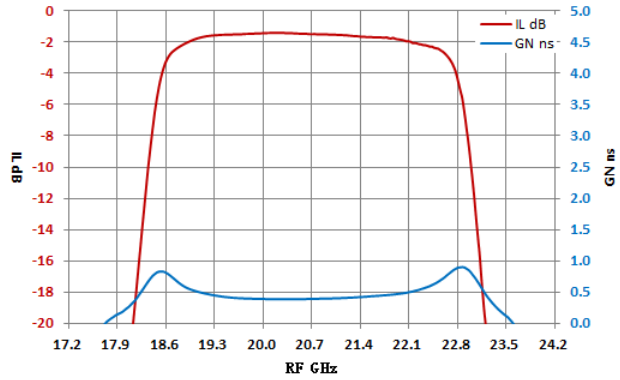
注意事项

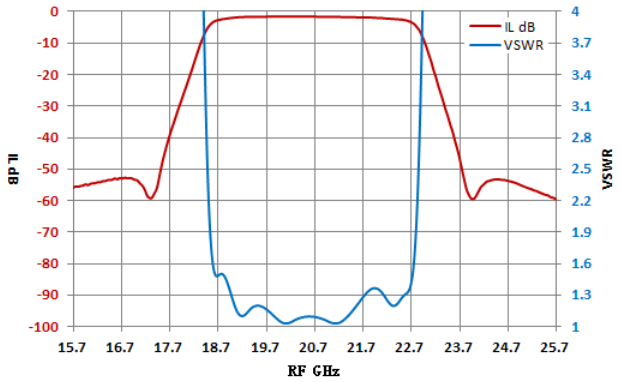
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

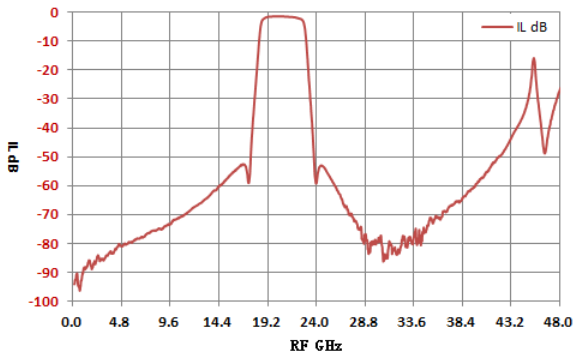
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

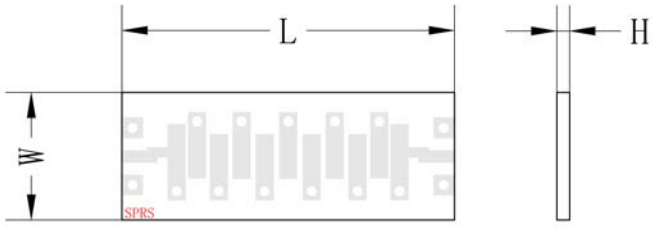
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	20.15	GHz
工作带宽	18.9-21.4	GHz
中心损耗	2.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-17.2GHz	dBc
带外抑制	40@23.1-40.0GHz	dBc

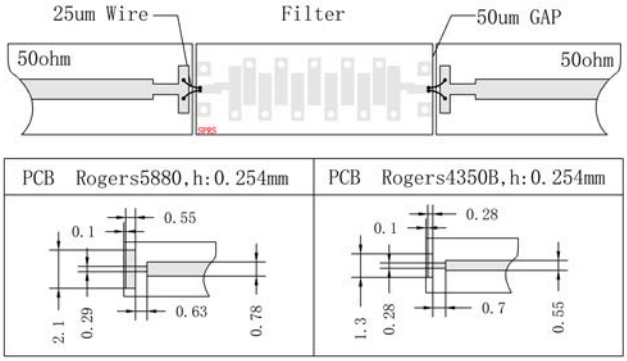
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



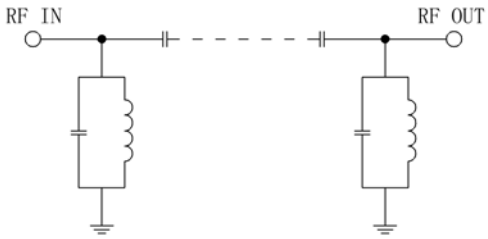
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

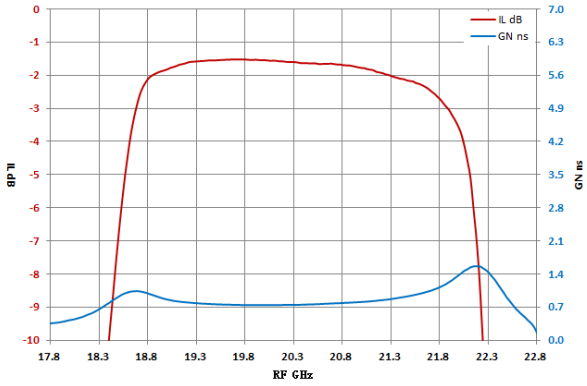
参考实物图

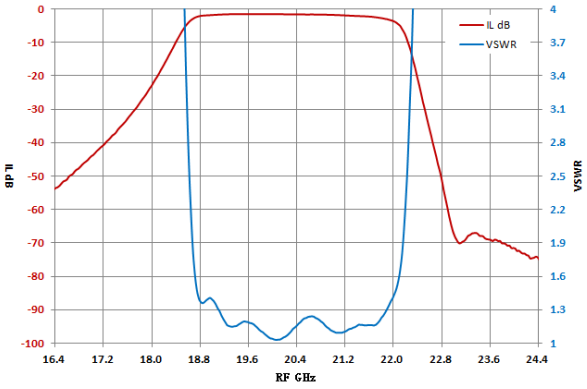


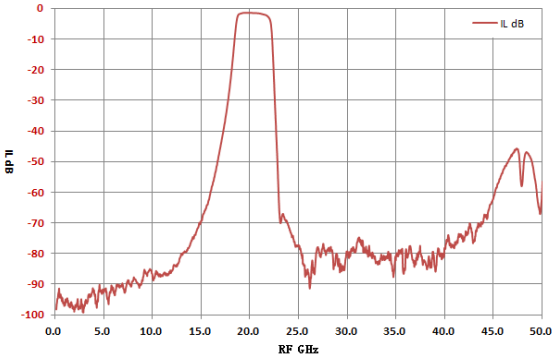
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

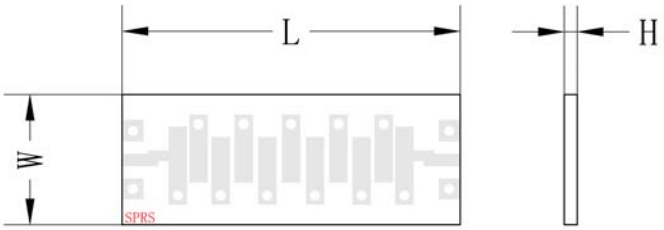
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	19.05	GHz
工作带宽	19.0-19.1	GHz
中心损耗	6.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-18.2GHz	dBc
带外抑制	40@19.8-48.0GHz	dBc

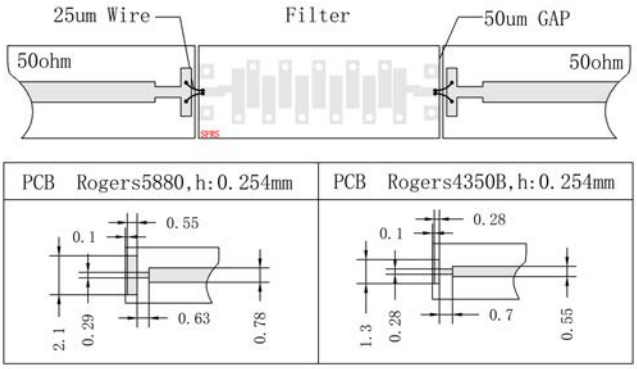
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：8.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

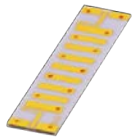
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

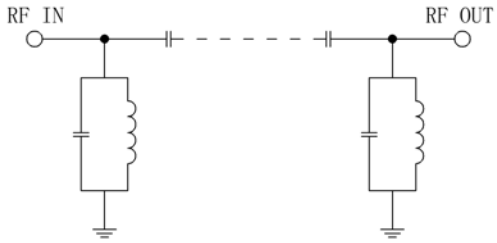
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

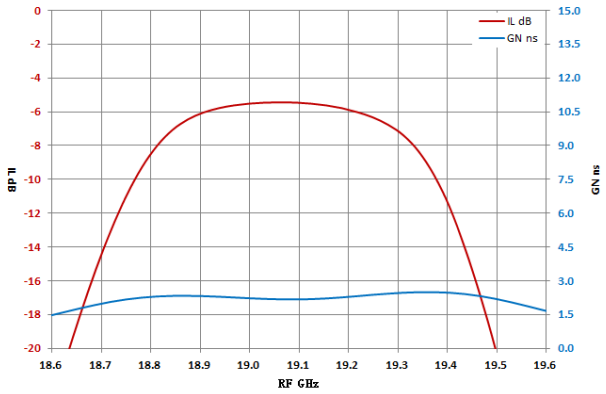
参考图

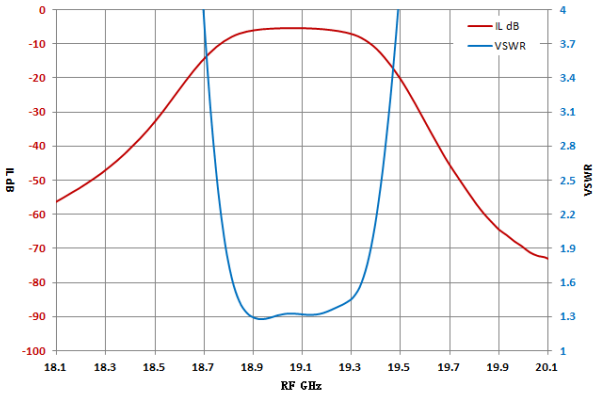


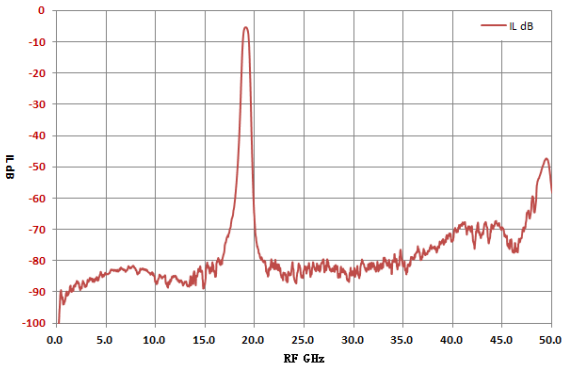
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

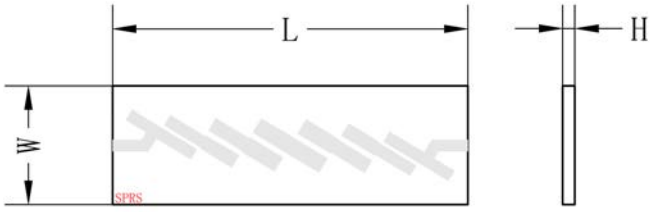
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	19.85	GHz
工作带宽	19.0-20.7	GHz
中心损耗	2.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-17.6GHz	dBc
带外抑制	40@22.0-35.0GHz	dBc

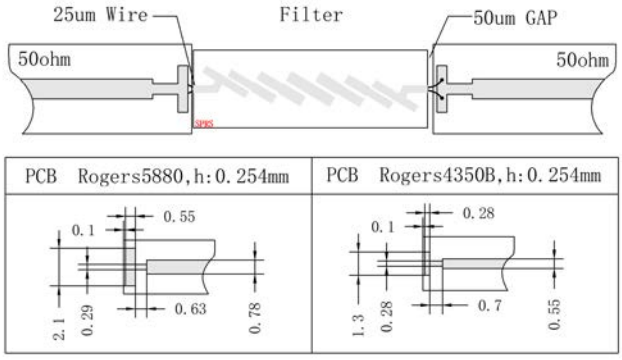
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.5，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



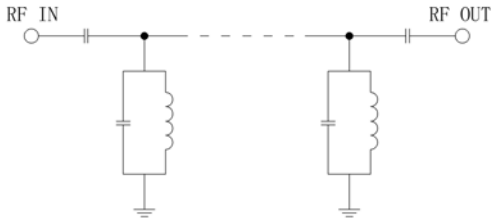
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

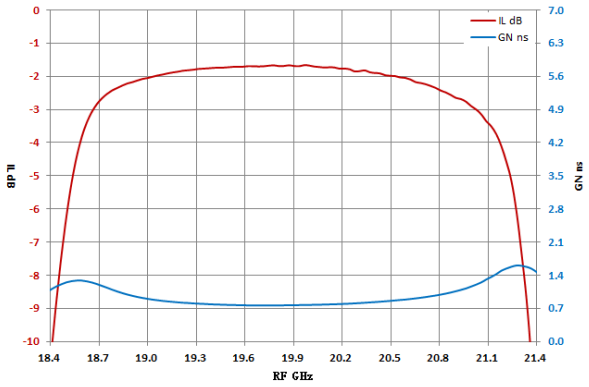
参考实物图

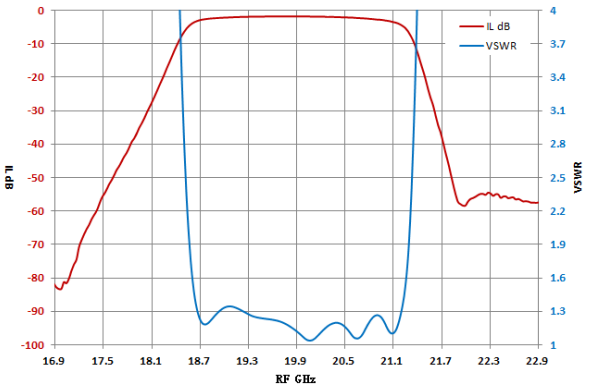


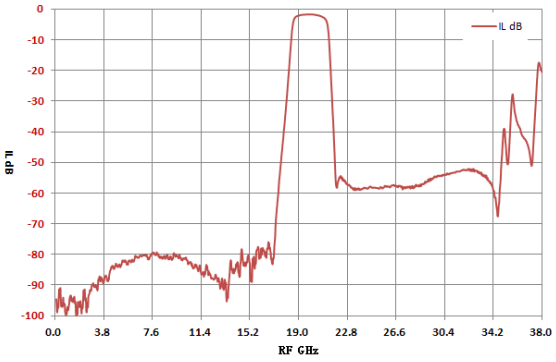
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

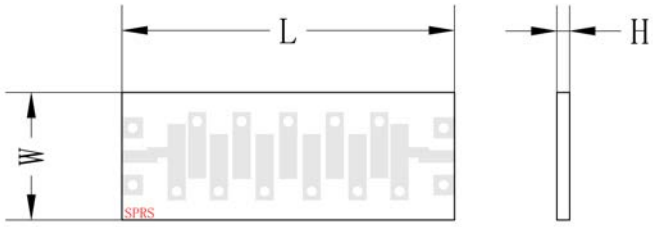
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	20.5	GHz
工作带宽	19.0-22.0	GHz
中心损耗	2.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-17.5GHz	dBc
带外抑制	40@23.7-43.0GHz	dBc

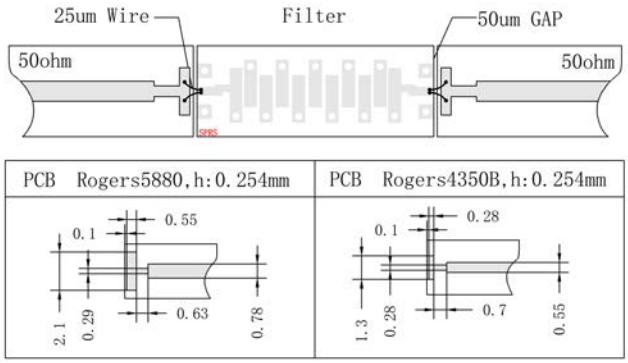
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



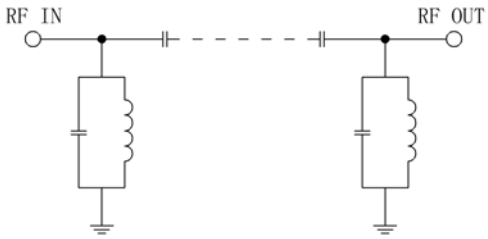
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

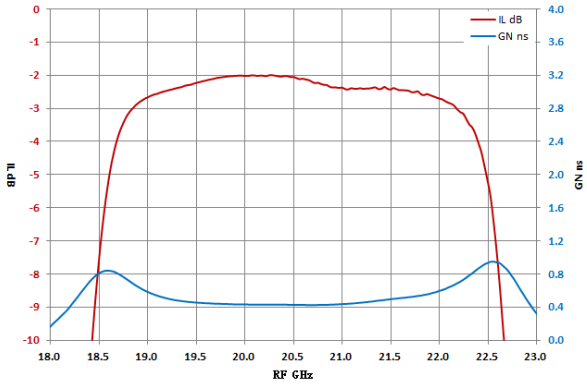
参考实物图

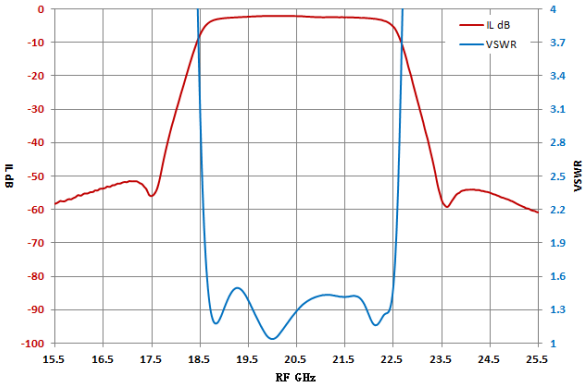


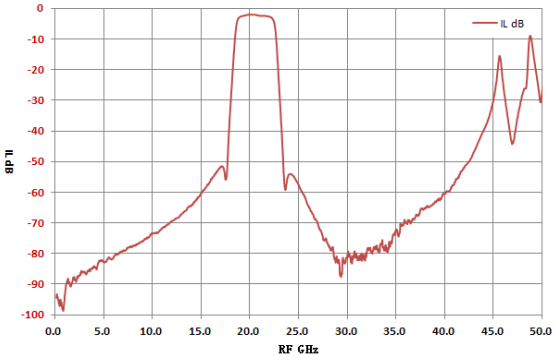
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

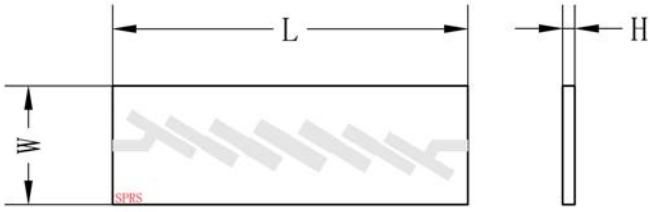
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	19.6	GHz
工作带宽	19.2-20.0	GHz
中心损耗	2.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-18.2GHz	dBc
带外抑制	40@21.2-27.0GHz	dBc

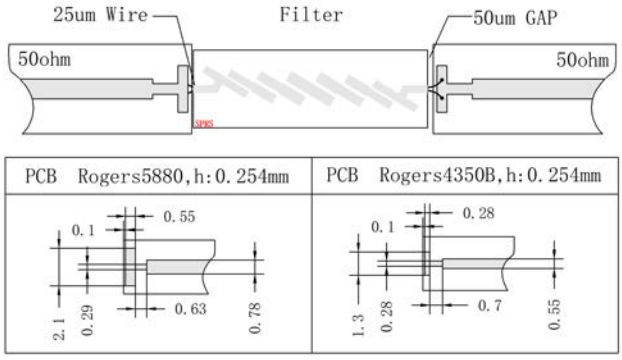
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.9，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



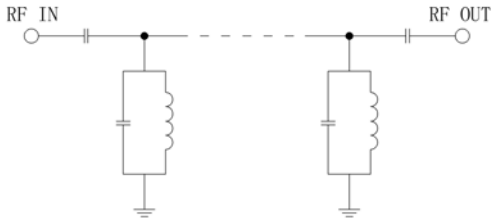
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.7mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

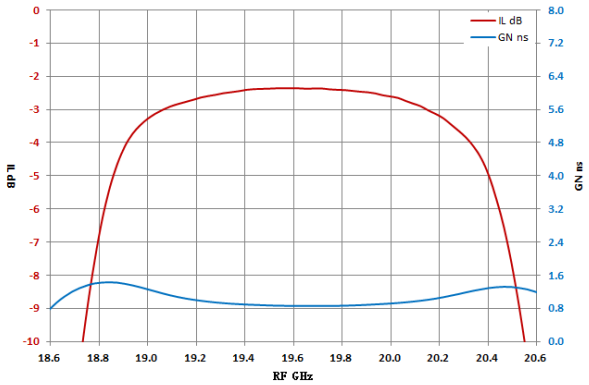
参考实物图

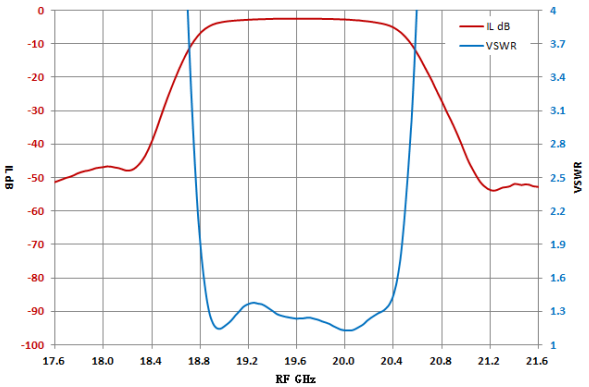


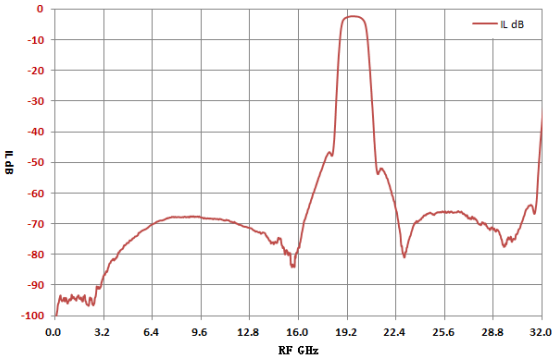
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



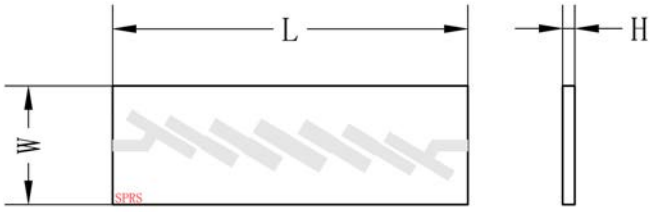
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	19.9	GHz
工作带宽	19.2-20.6	GHz
中心损耗	2.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-17.9GHz	dBc
带外抑制	40@22.0-30.0GHz	dBc

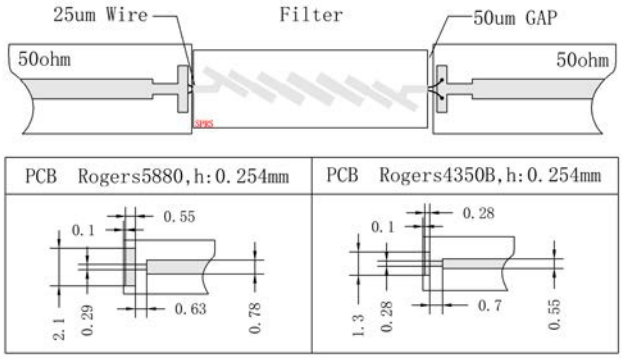
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



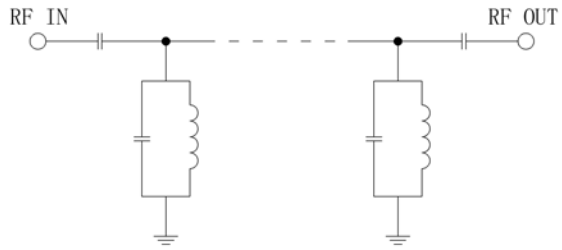
推荐装配图



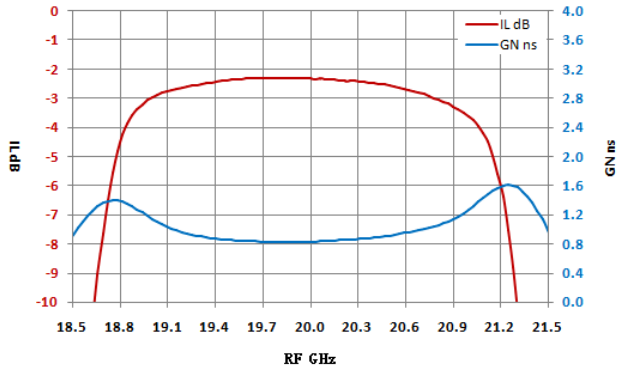
注意事项

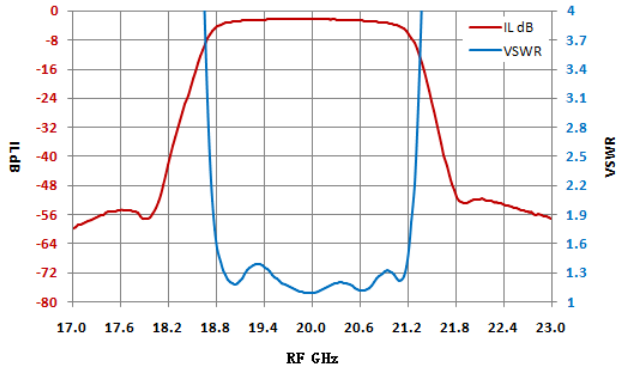
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

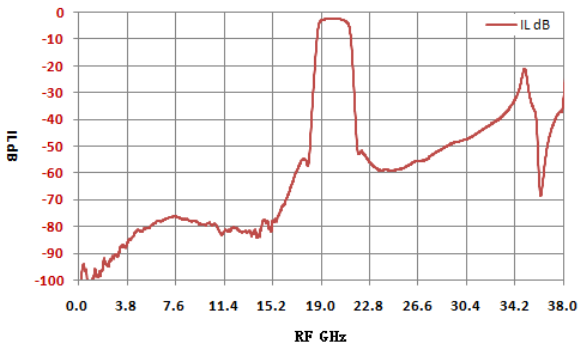
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



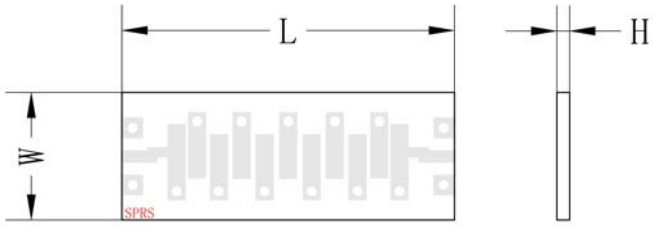
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	20.4	GHz
工作带宽	19.2-21.6	GHz
中心损耗	2.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-17.5GHz	dBc
带外抑制	40@23.3-36.0GHz	dBc

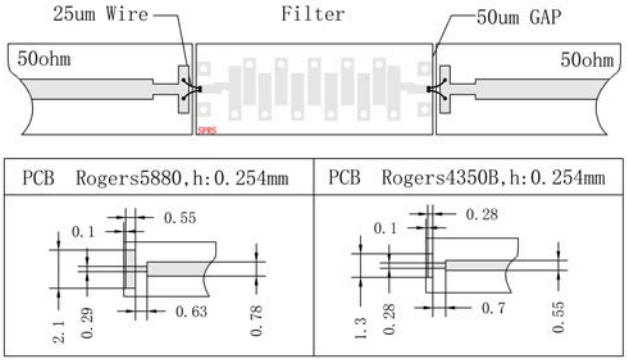
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



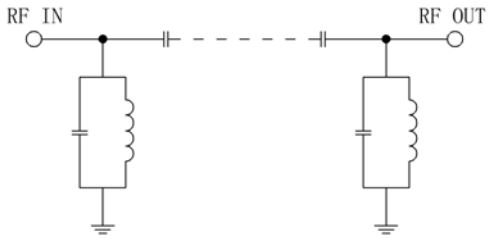
推荐装配图



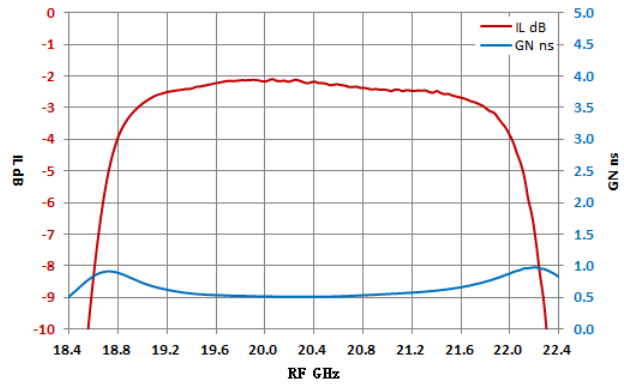
注意事项

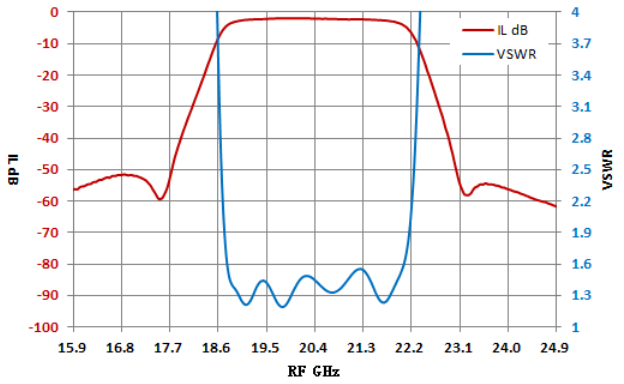
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

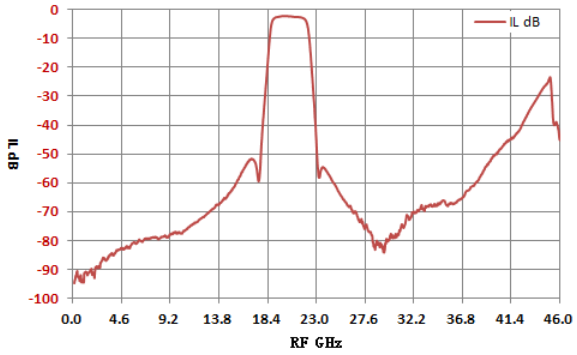
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



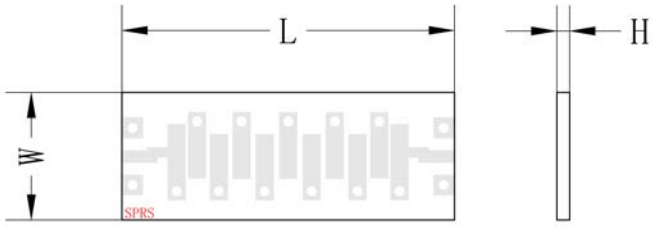
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	24.7	GHz
工作带宽	19.2-30.2	GHz
中心损耗	2.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-16.3GHz	dBc
带外抑制	40@33.2-56.0GHz	dBc

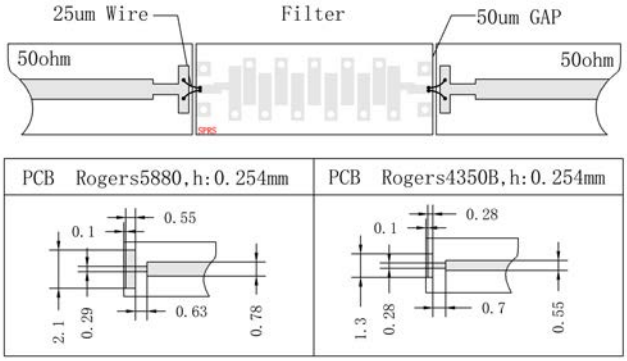
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



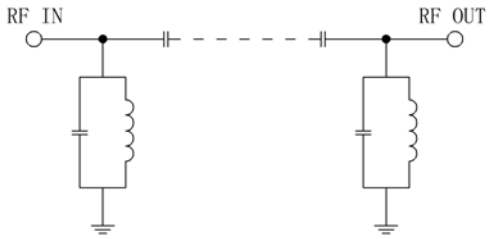
推荐装配图



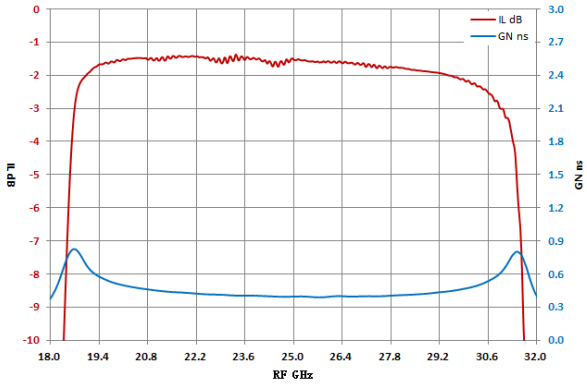
注意事项

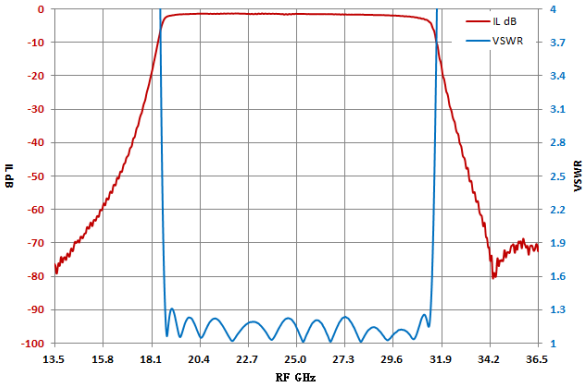
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

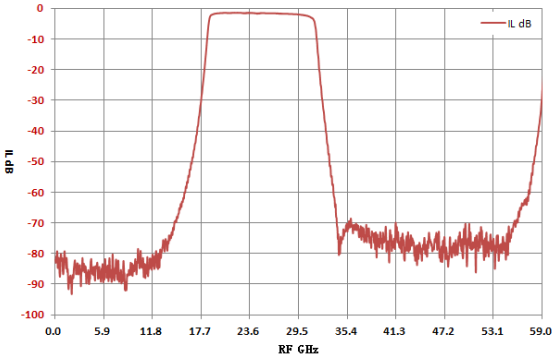
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



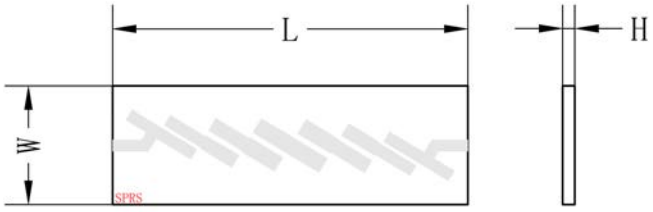
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	19.3	GHz
工作带宽	0	GHz
中心损耗	9.0	dB
带内波动	0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0	ns
带外抑制	30@DC-18.6GHz	dBc
带外抑制	40@20.0-27.0GHz	dBc

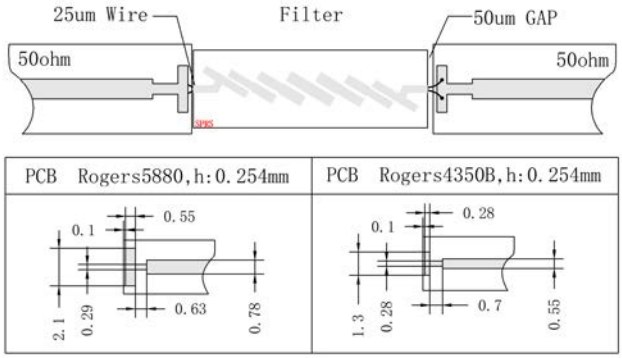
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



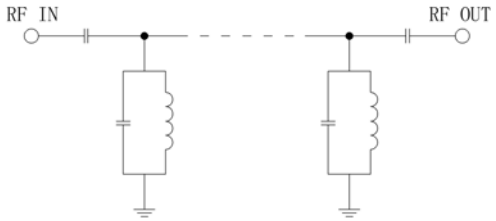
推荐装配图



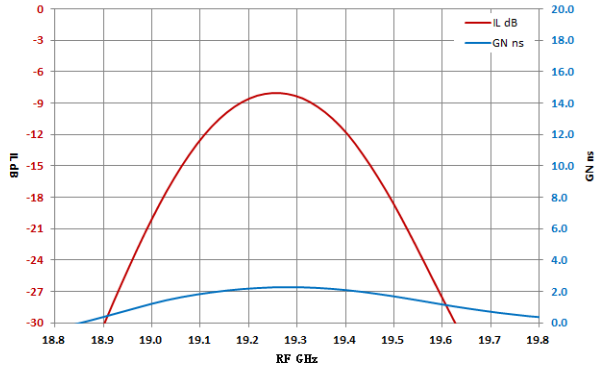
注意事项

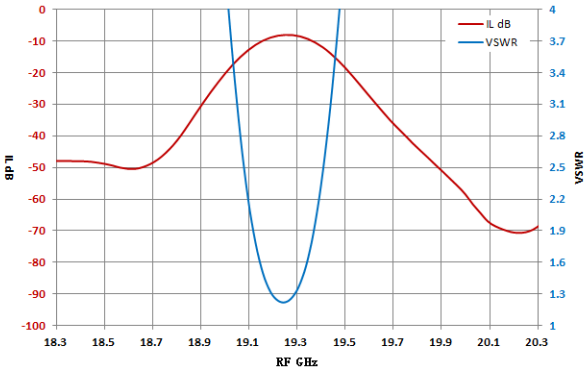
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

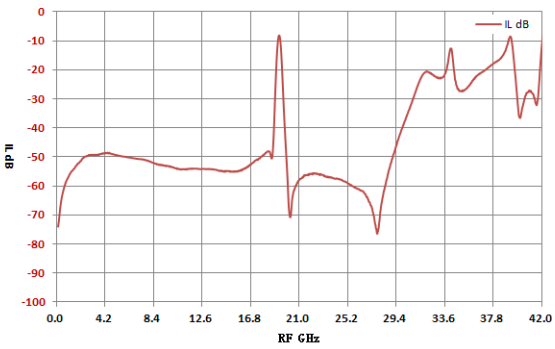
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



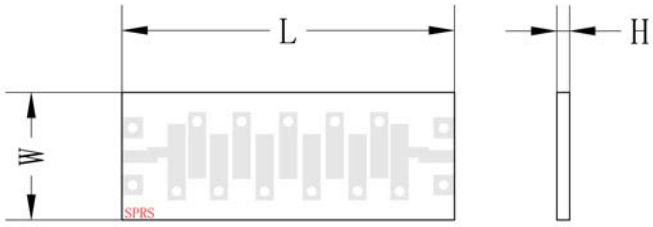
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	22.1	GHz
工作带宽	19.4-24.8	GHz
中心损耗	1.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-15.8GHz	dBc
带外抑制	40@27.5-44.0GHz	dBc

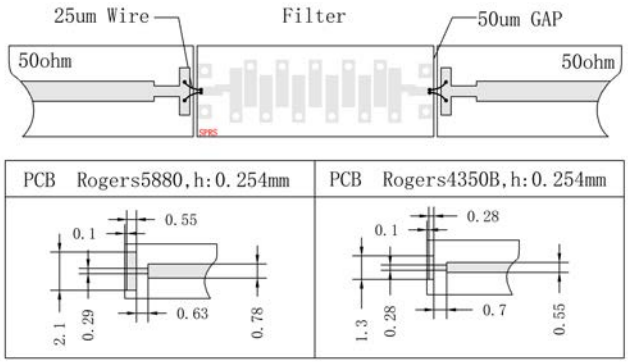
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



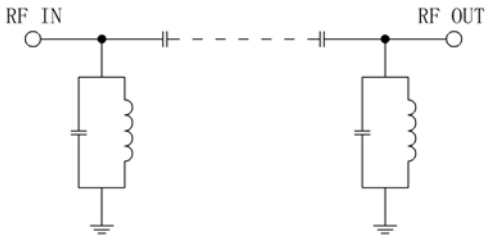
推荐装配图



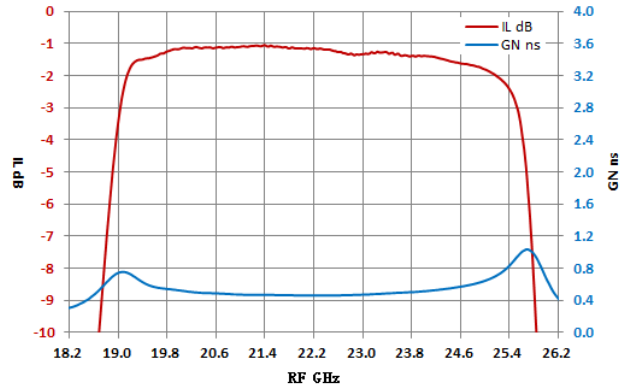
注意事项

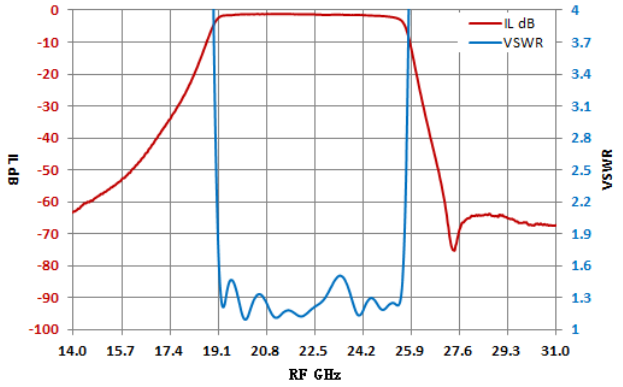
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

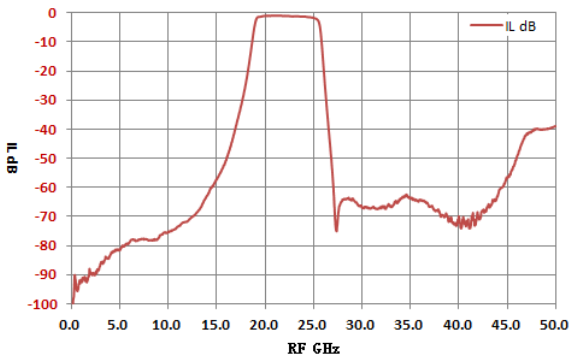
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

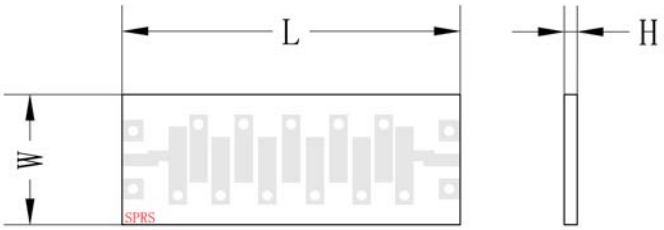
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	20.0	GHz
工作带宽	19.5-20.5	GHz
中心损耗	3.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	35@DC-18.5GHz	dBc
带外抑制	45@21.9-48.0GHz	dBc

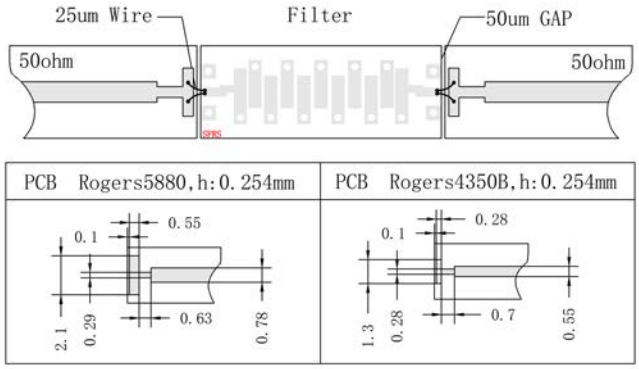
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.74mm,端口可互换;

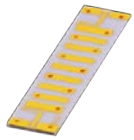
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

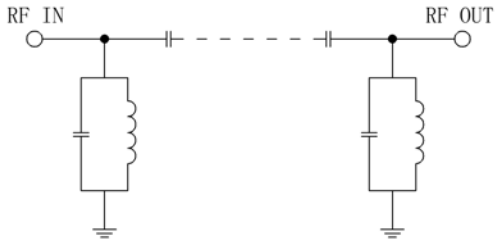
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

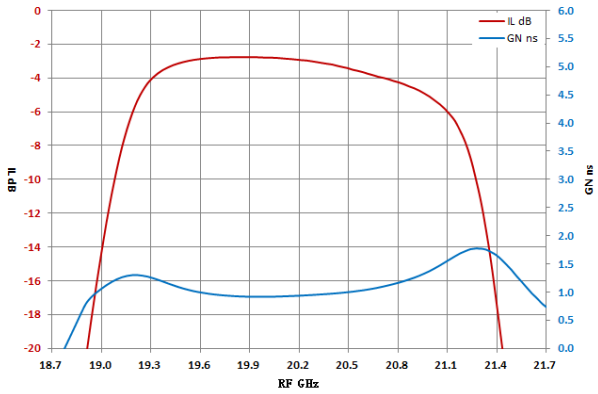
参考图

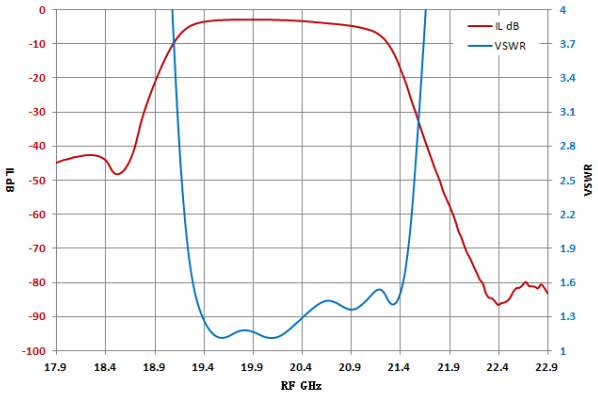


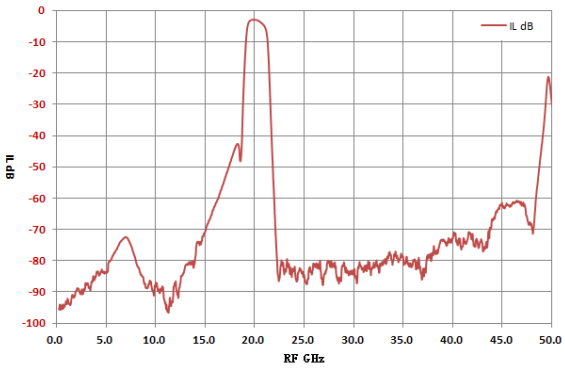
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

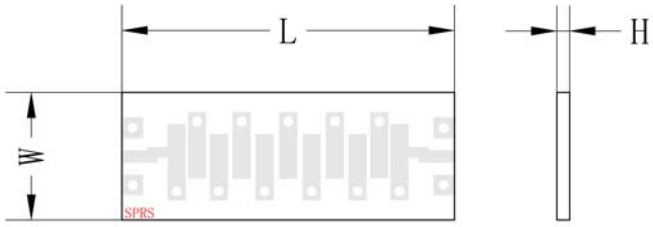
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	20.35	GHz
工作带宽	19.6-21.1	GHz
中心损耗	2.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-18.0GHz	dBc
带外抑制	40@22.5-42.0GHz	dBc

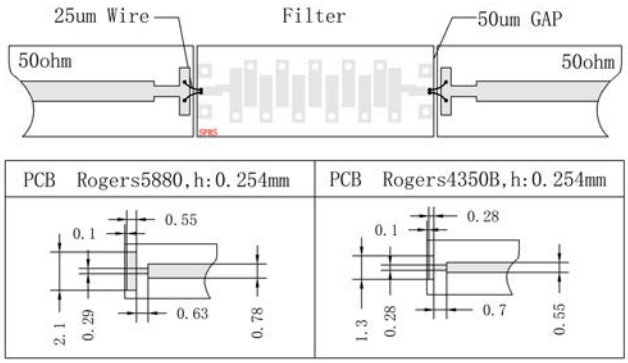
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



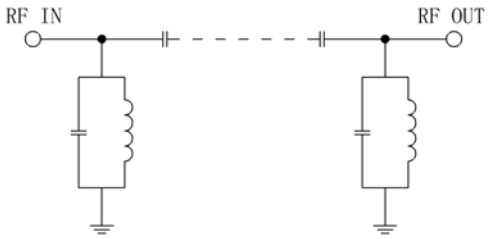
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

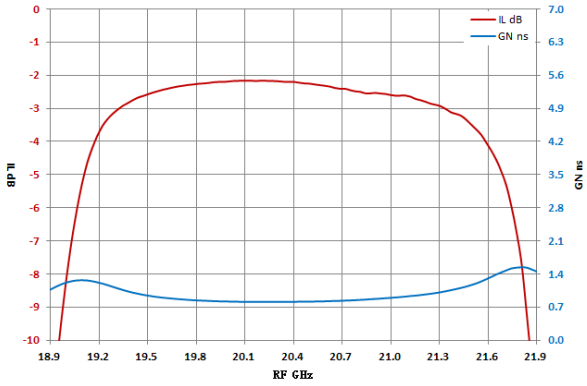
参考实物图

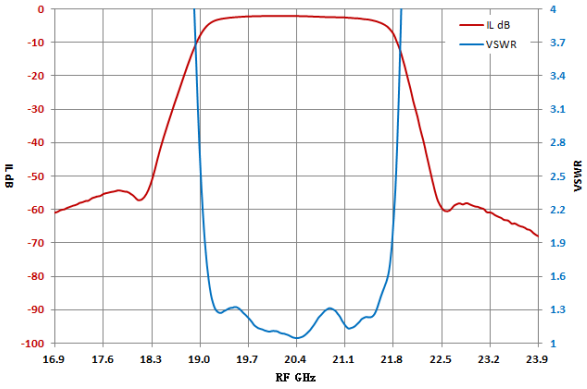


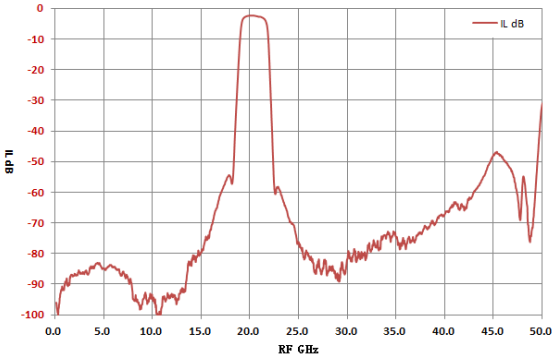
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

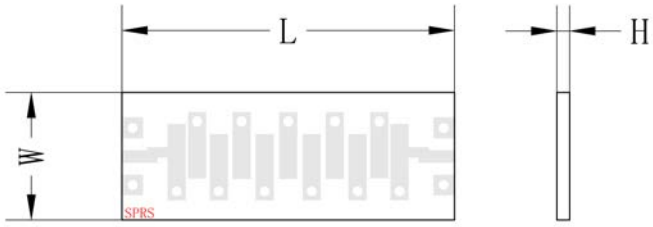
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	21.8	GHz
工作带宽	19.6-24.0	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-18.0GHz	dBc
带外抑制	40@26.0-46.0GHz	dBc

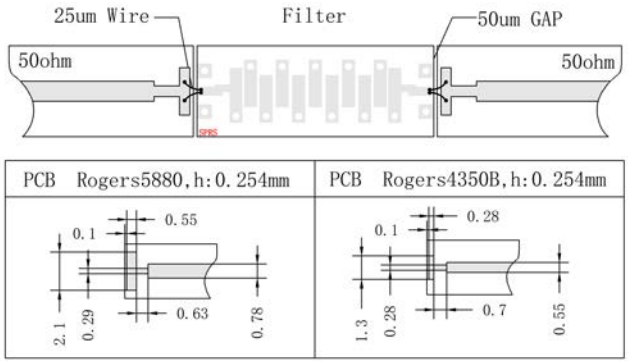
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



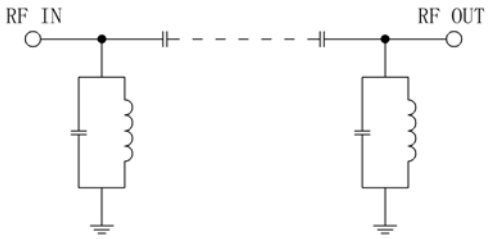
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

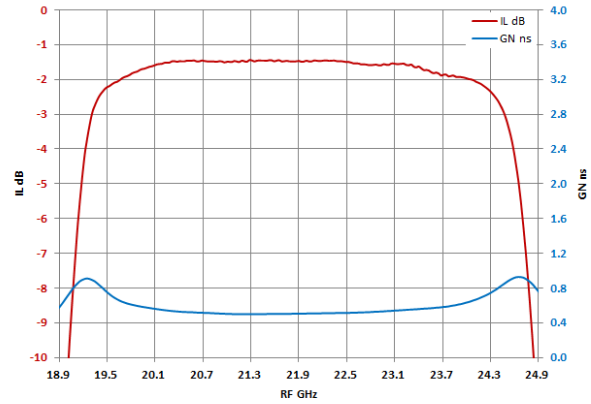
参考实物图

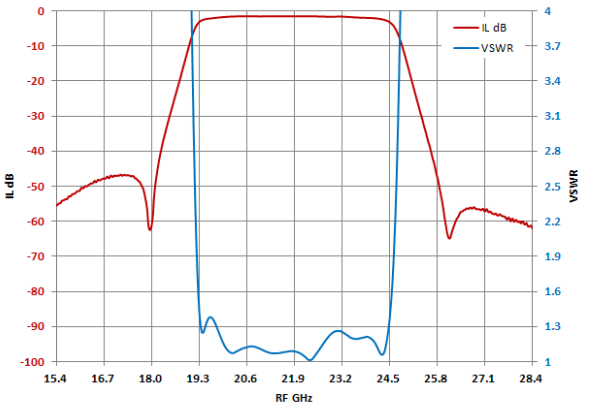


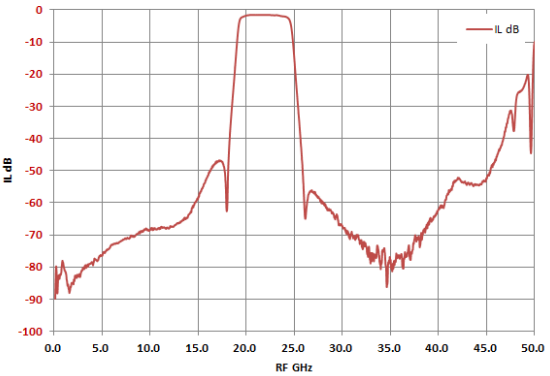
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

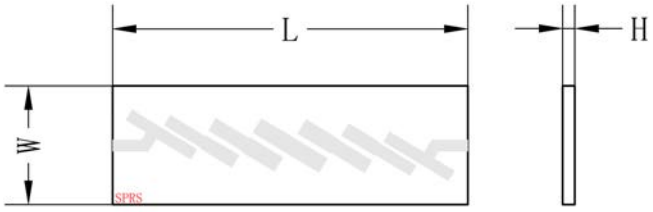
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	19.95	GHz
工作带宽	19.8-20.1	GHz
中心损耗	3.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-19.0GHz	dBc
带外抑制	40@21.0-34.0GHz	dBc

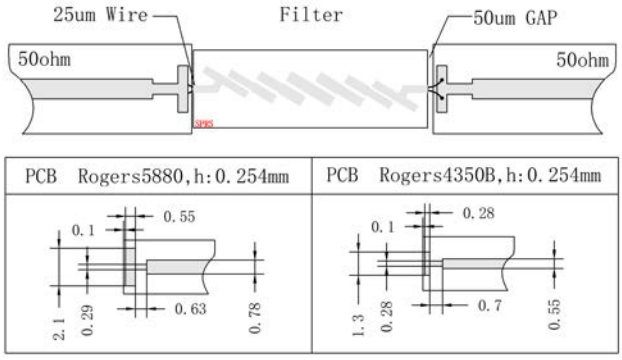
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：10.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



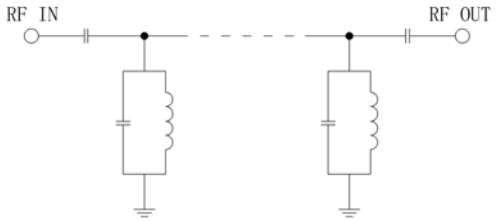
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

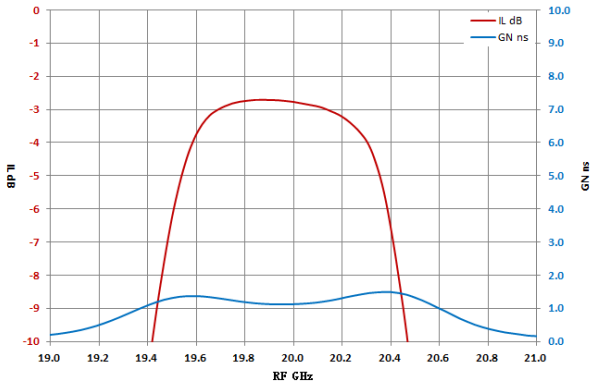
参考实物图

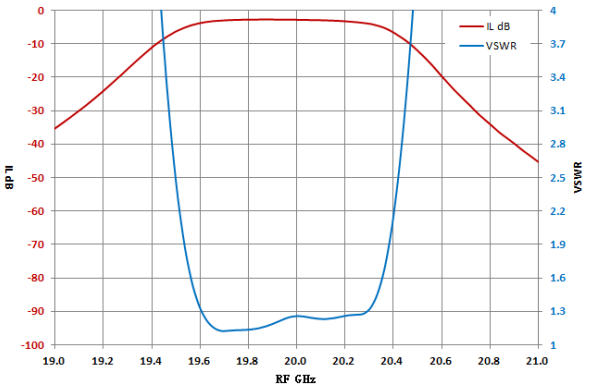


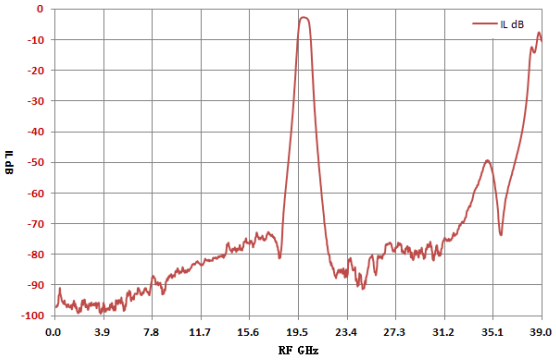
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

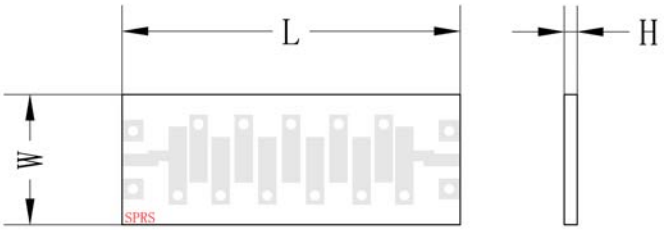
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	20.05	GHz
工作带宽	19.8-20.3	GHz
中心损耗	2.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	45@DC-18.4GHz	dBc
带外抑制	45@22.2-40.0GHz	dBc

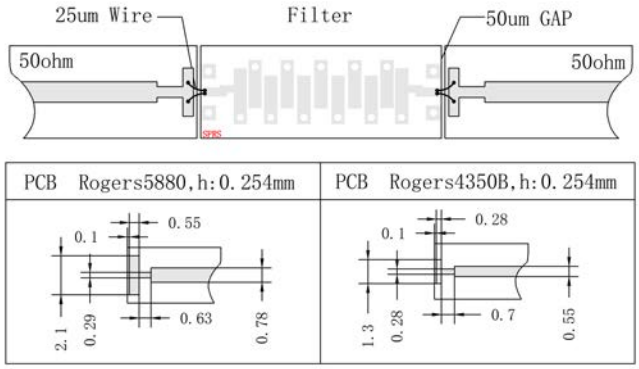
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：6.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

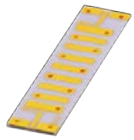
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

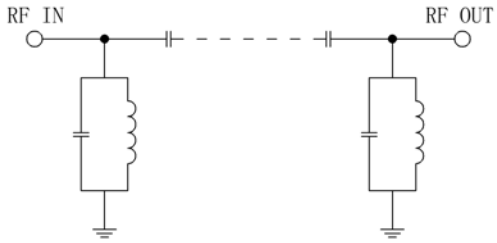
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

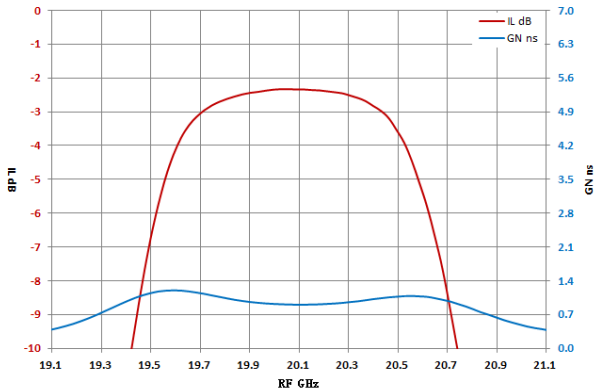
参考图

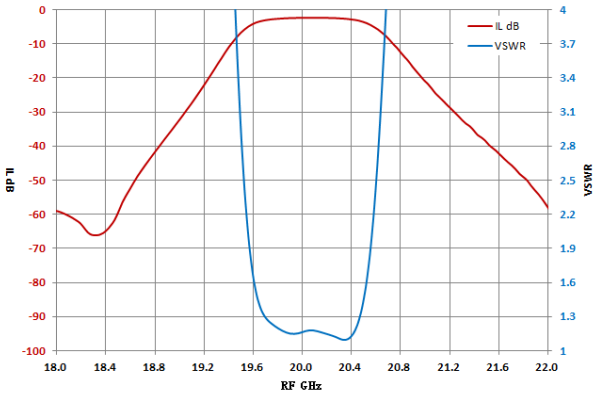


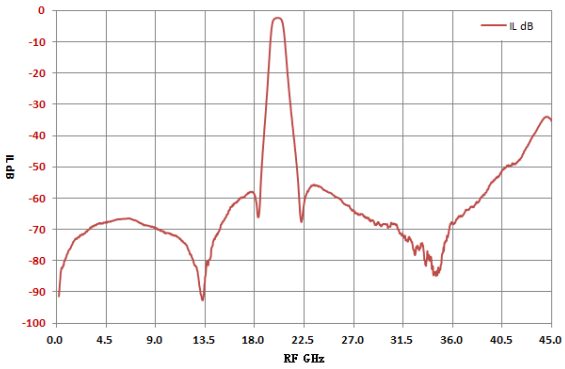
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



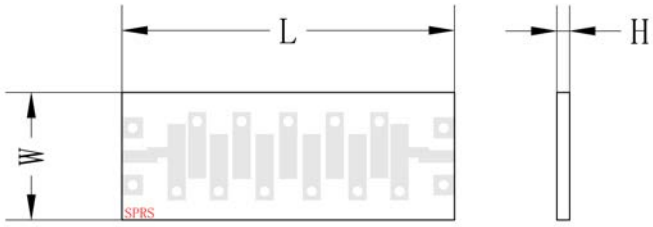
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	22.3	GHz
工作带宽	19.8-24.8	GHz
中心损耗	2.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-17.5GHz	dBc
带外抑制	40@27.0-45.0GHz	dBc

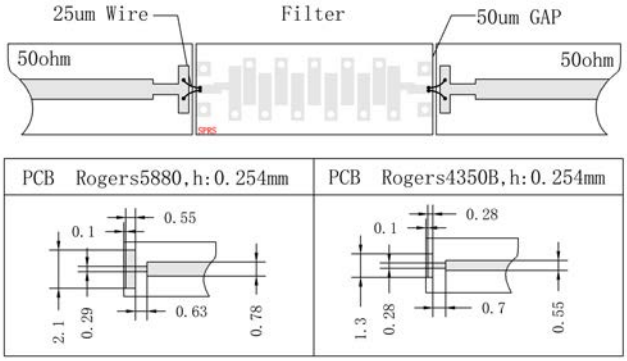
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.2，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



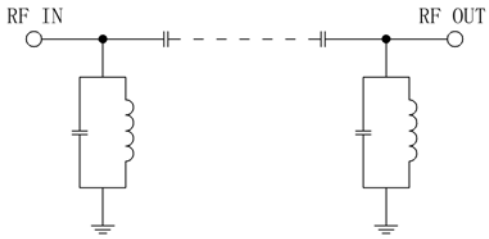
推荐装配图



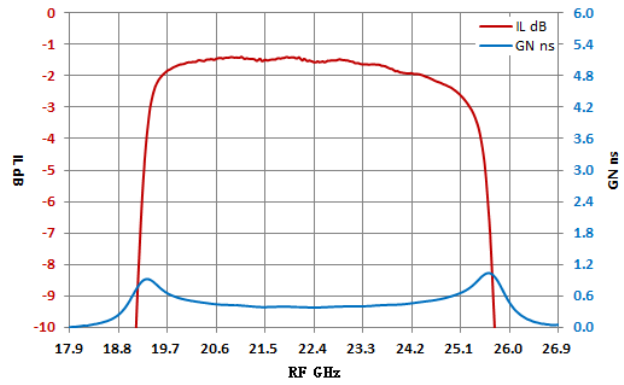
注意事项

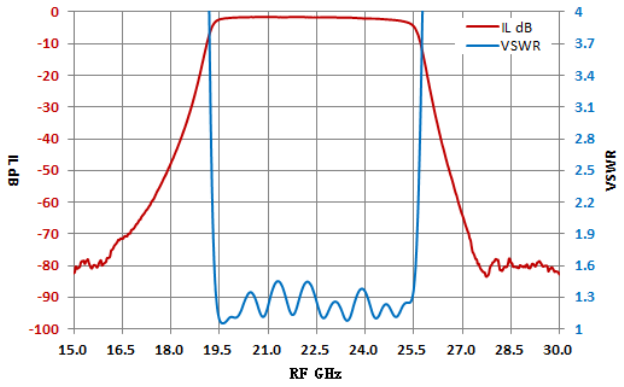
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

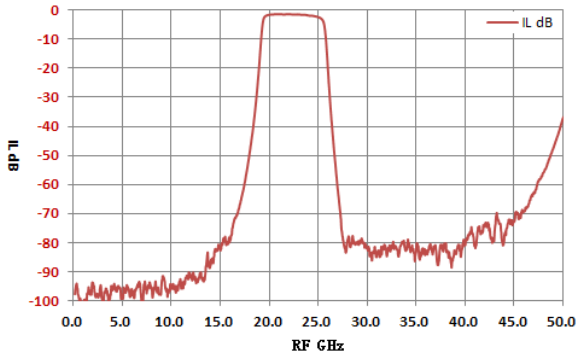
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

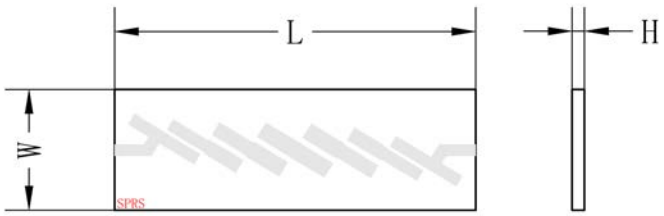
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	22.7	GHz
工作带宽	19.8-25.6	GHz
中心损耗	1.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-17.2GHz	dBc
带外抑制	40@29.4-40.0GHz	dBc

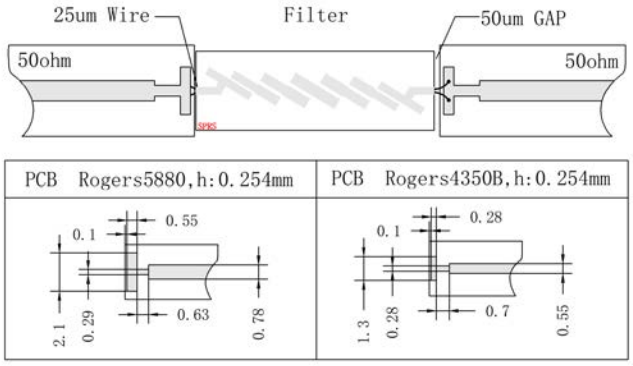
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：12.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

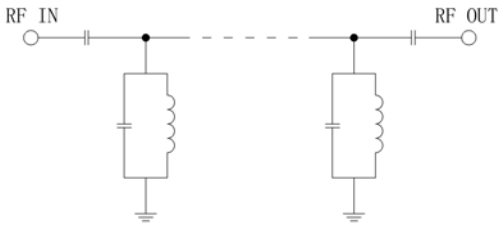
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

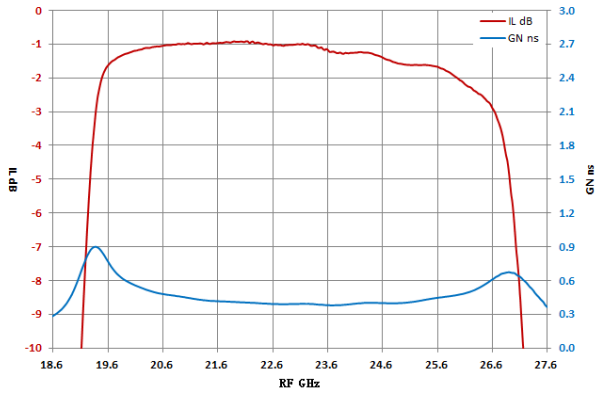
参考图

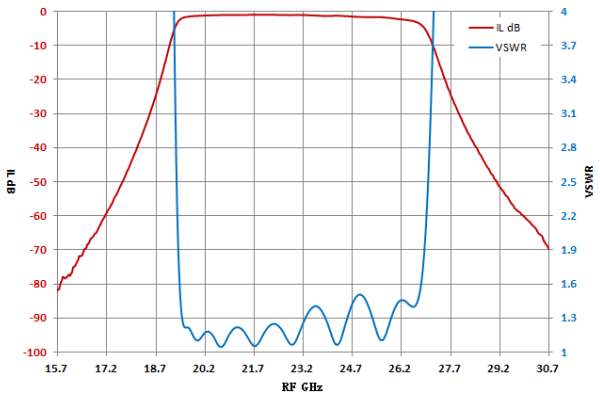


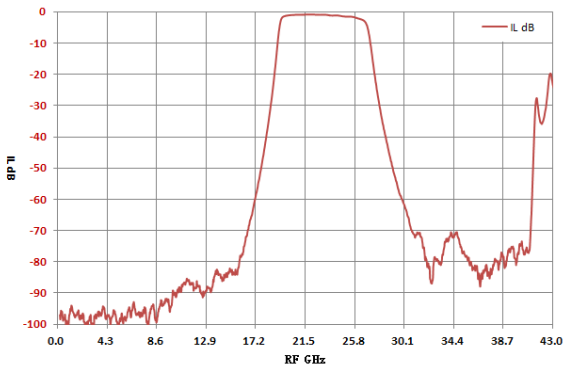
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

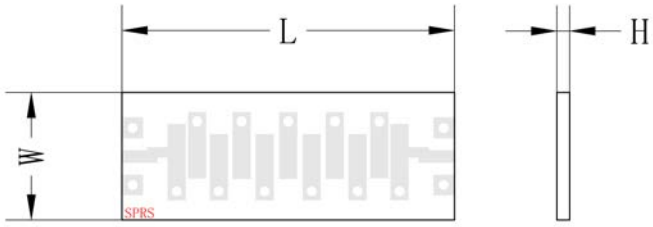
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	24.7	GHz
工作带宽	19.8-29.6	GHz
中心损耗	1.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-14.2GHz	dBc
带外抑制	40@36.3-49.0GHz	dBc

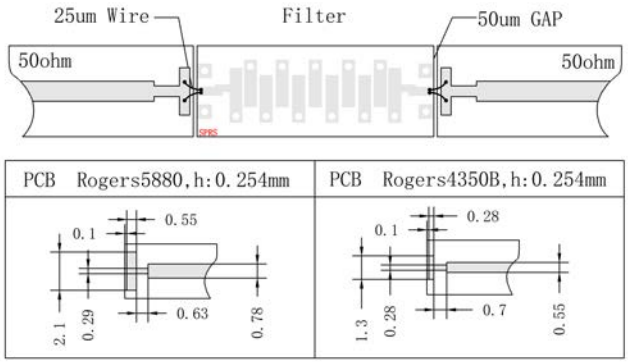
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



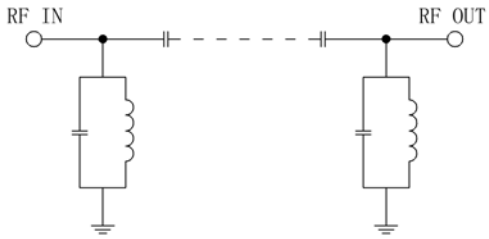
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.87mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

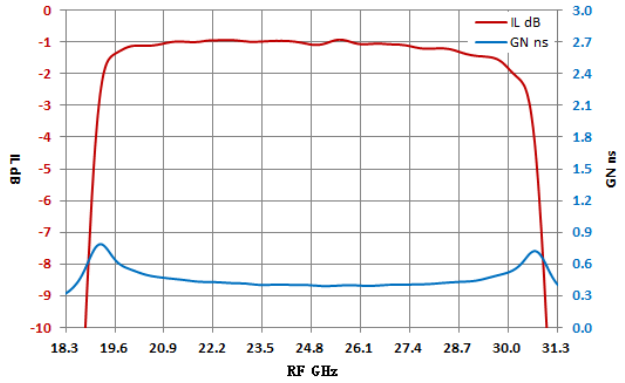
参考实物图

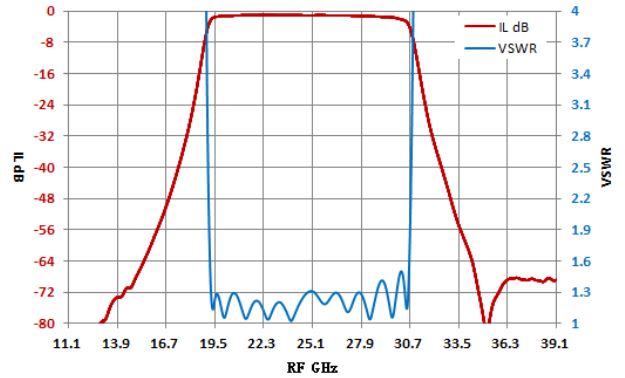


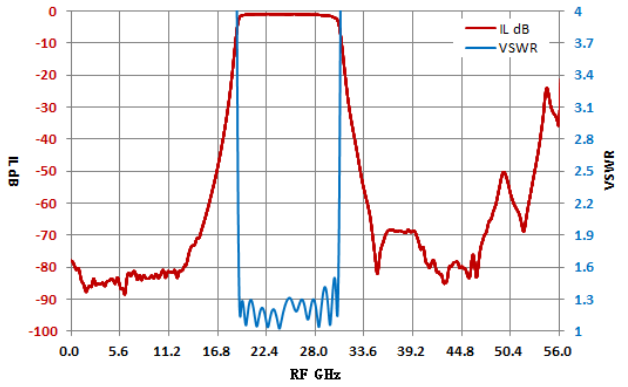
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



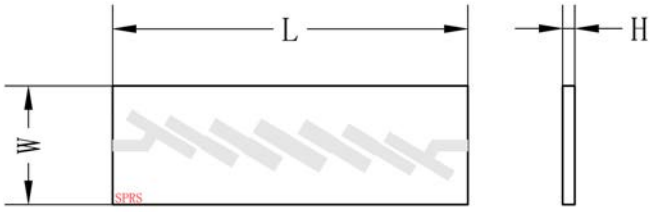
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	20.6	GHz
工作带宽	20.0-21.2	GHz
中心损耗	3.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	35@DC-18.6GHz	dBc
带外抑制	40@22.9-30.0GHz	dBc

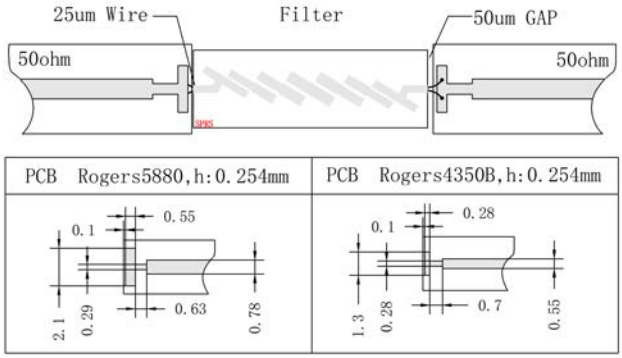
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



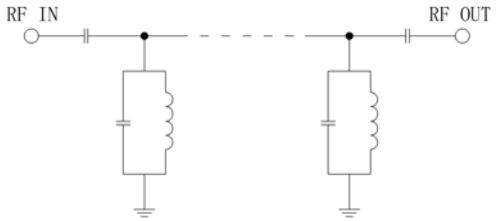
推荐装配图



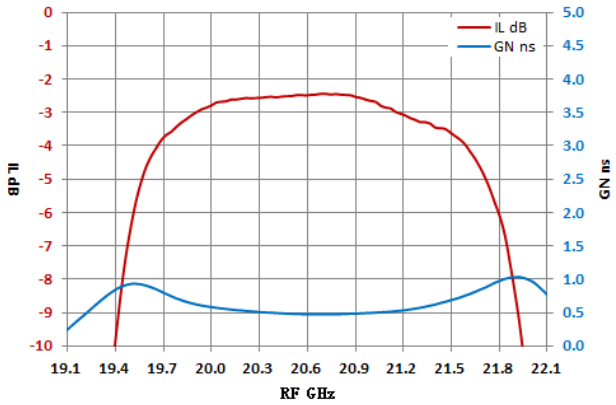
注意事项

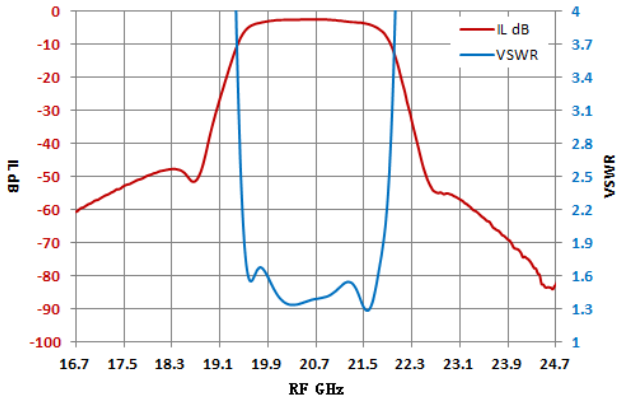
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

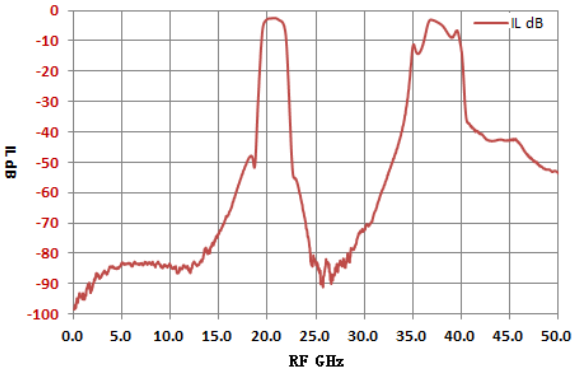
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



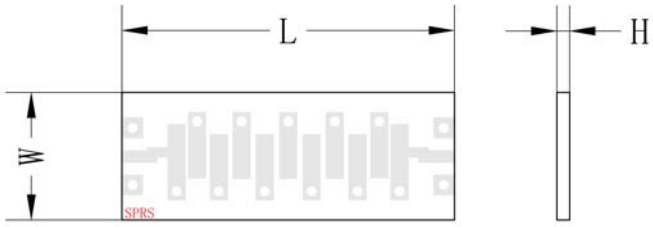
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	20.9	GHz
工作带宽	20.2-21.6	GHz
中心损耗	3.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-18.6GHz	dBc
带外抑制	40@23.0-46.0GHz	dBc

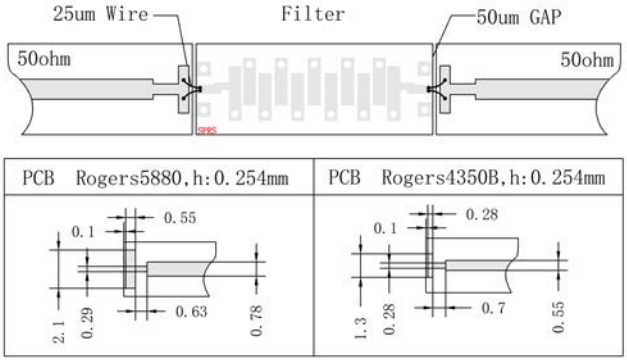
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



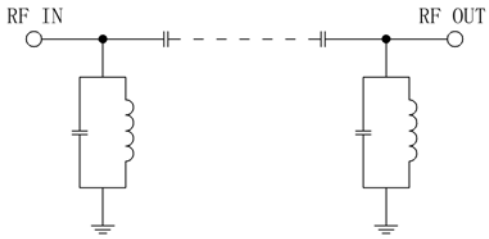
推荐装配图



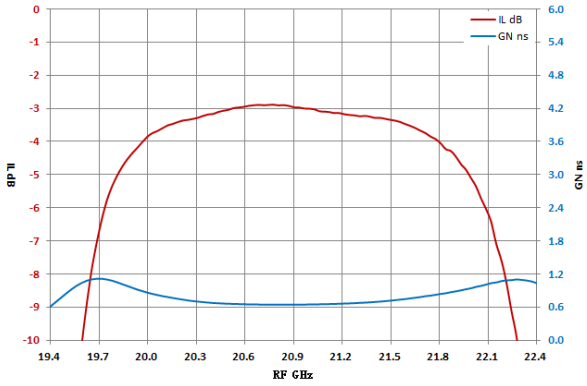
注意事项

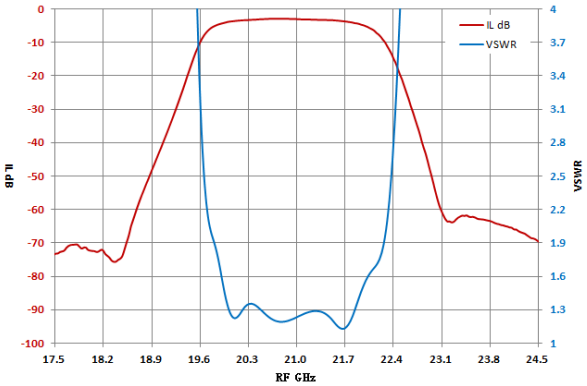
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

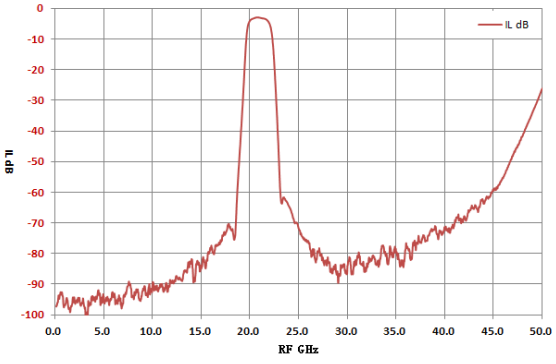
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



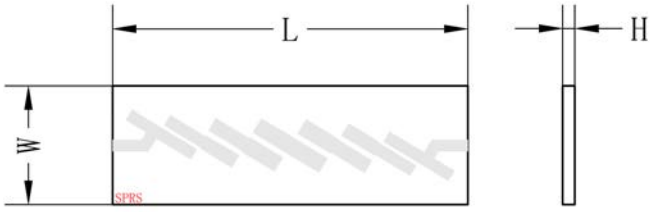
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	22.0	GHz
工作带宽	20.0-24.0	GHz
中心损耗	1.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-17.4GHz	dBc
带外抑制	40@27.1-33.0GHz	dBc

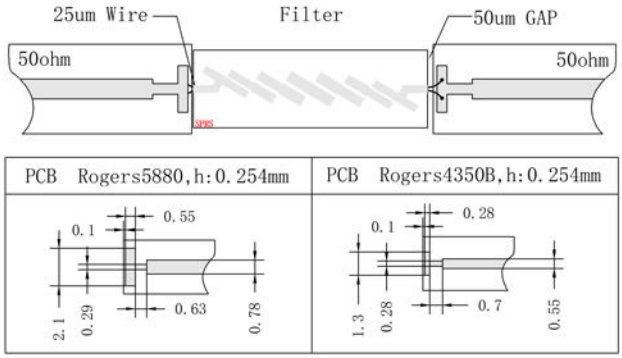
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



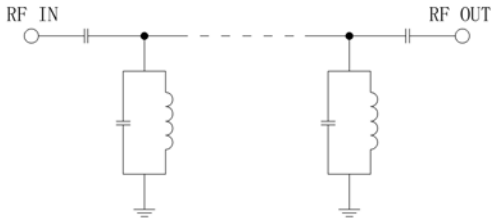
推荐装配图



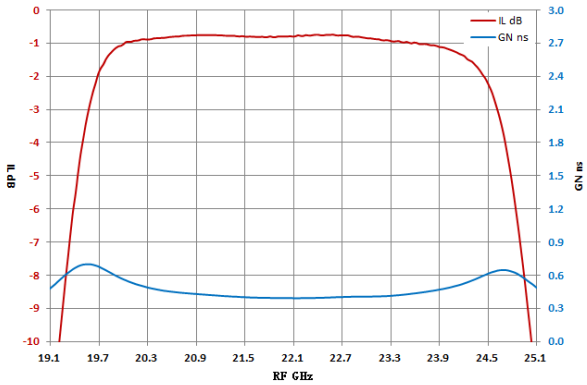
注意事项

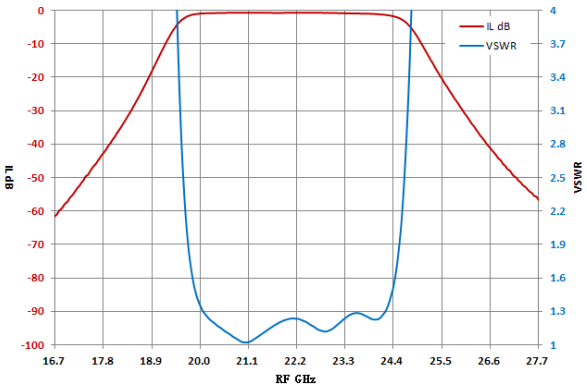
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

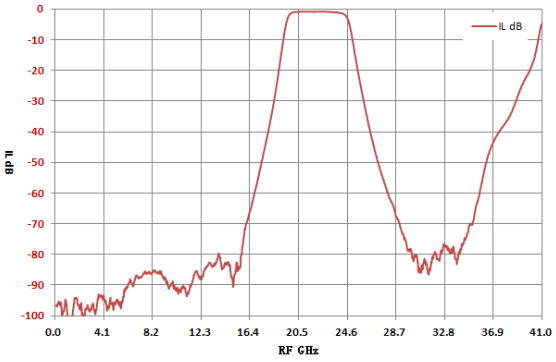
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



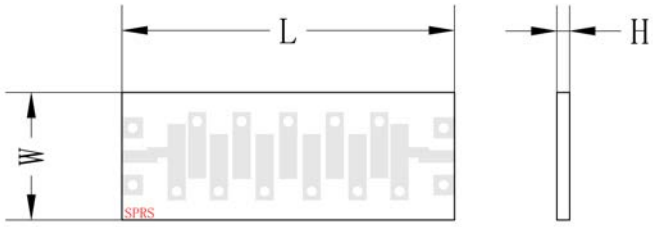
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	22.9	GHz
工作带宽	20.0-25.8	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-18.0GHz	dBc
带外抑制	40@28.3-50.0GHz	dBc

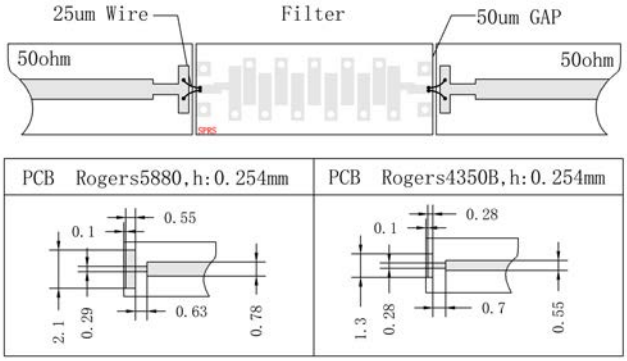
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



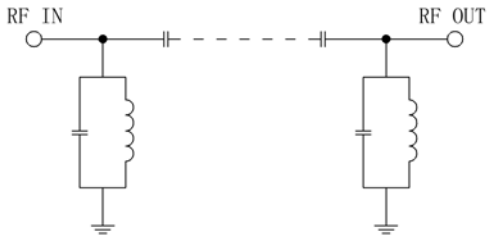
推荐装配图



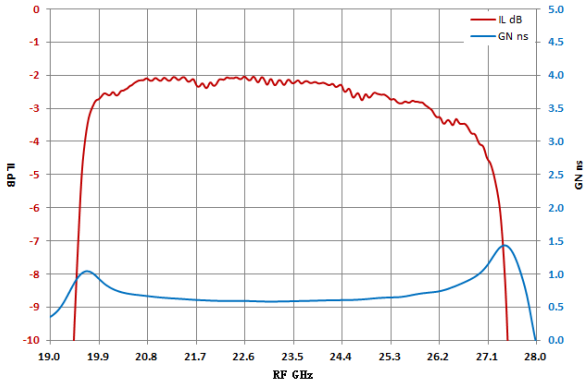
注意事项

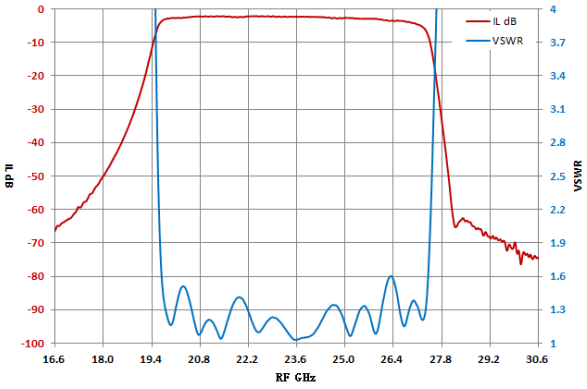
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

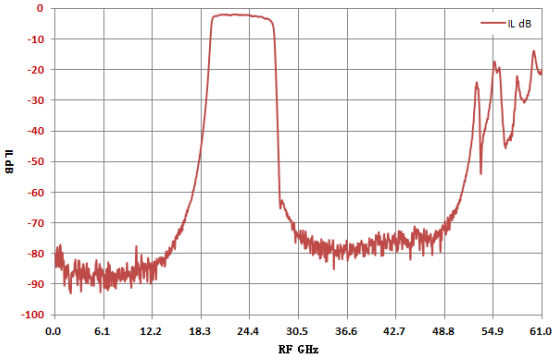
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



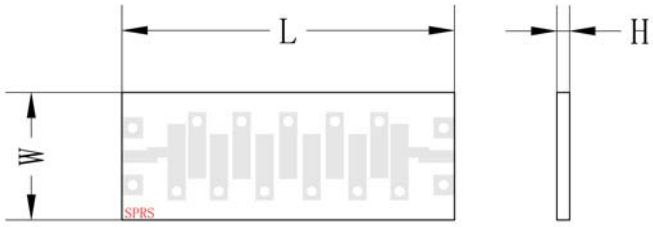
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	23.0	GHz
工作带宽	20.0-26.0	GHz
中心损耗	1.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-17.4GHz	dBc
带外抑制	40@28.6-44.0GHz	dBc

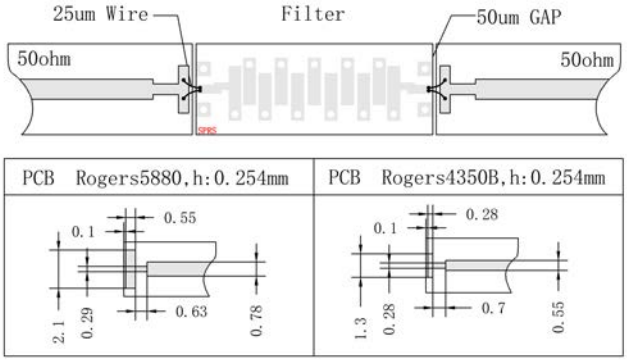
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



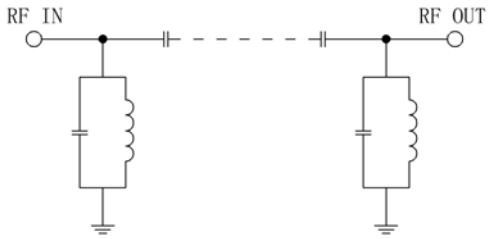
推荐装配图



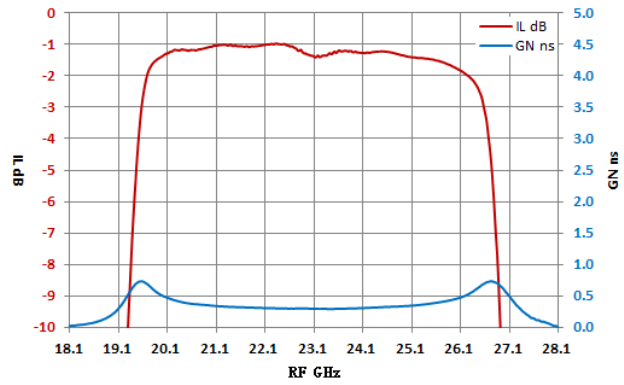
注意事项

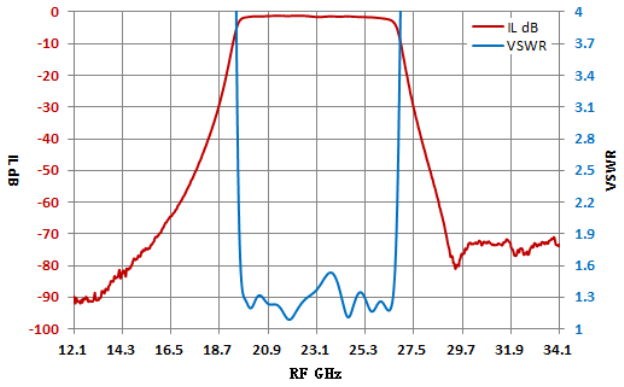
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

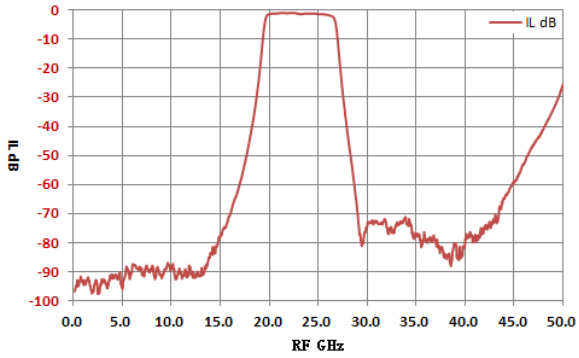
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

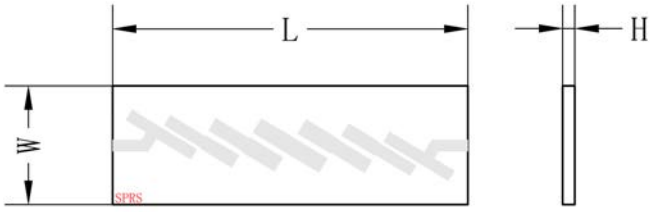
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	20.7	GHz
工作带宽	20.1-21.3	GHz
中心损耗	3.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-18.5GHz	dBc
带外抑制	40@23.0-37.0GHz	dBc

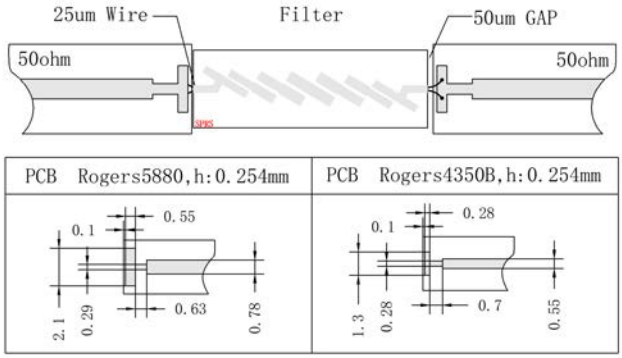
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



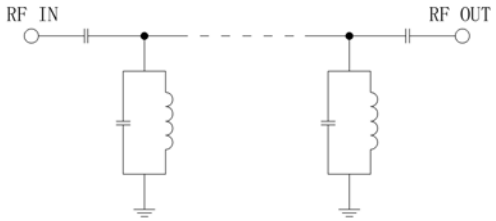
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

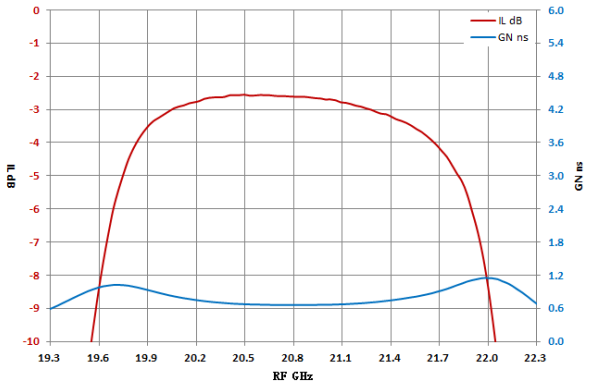
参考实物图

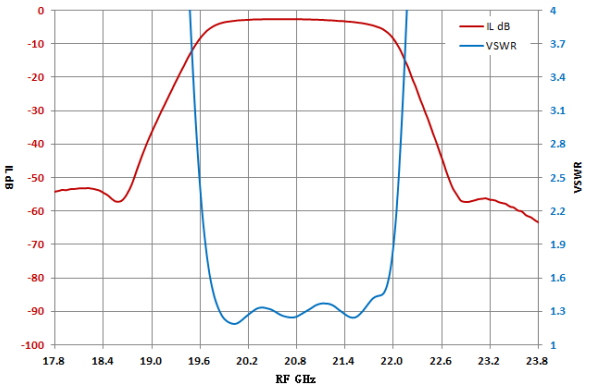


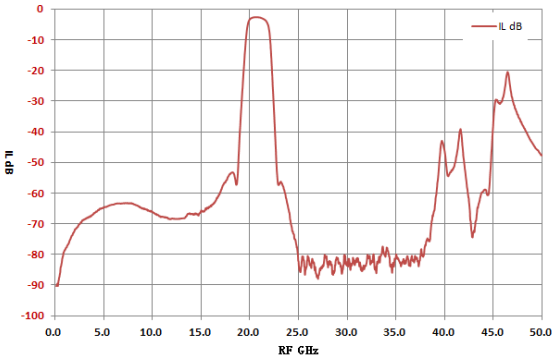
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

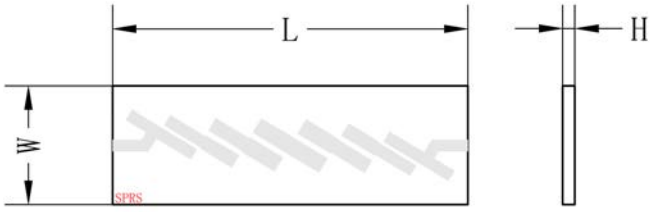
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	21.8	GHz
工作带宽	20.1-23.5	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-18.0GHz	dBc
带外抑制	40@25.0-35.0GHz	dBc

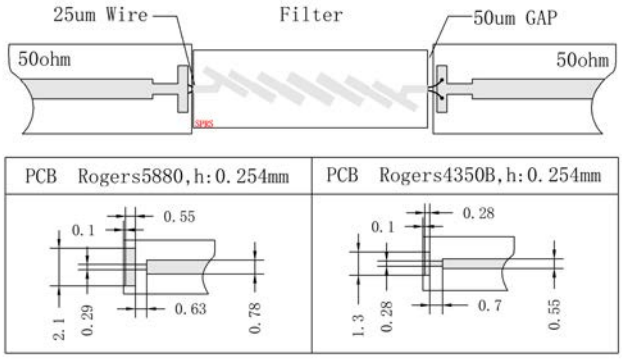
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



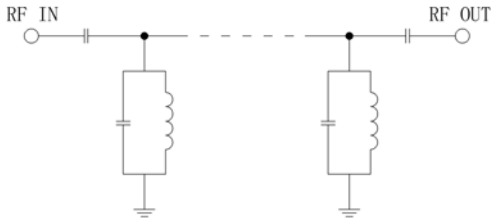
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

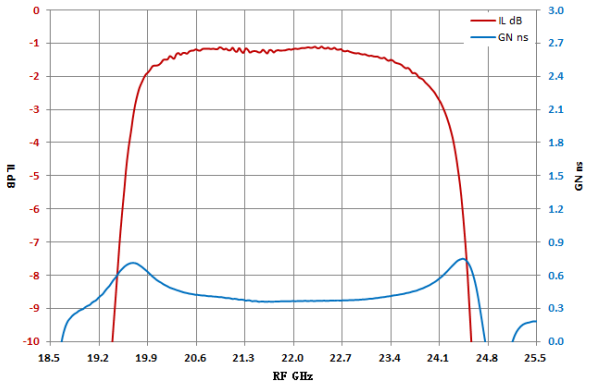
参考实物图

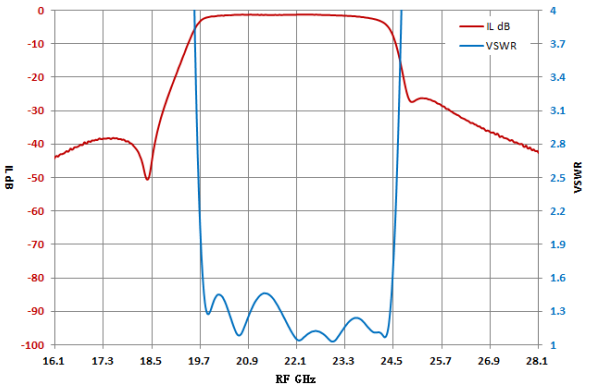


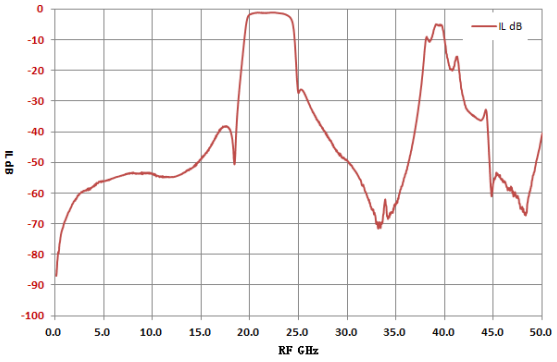
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

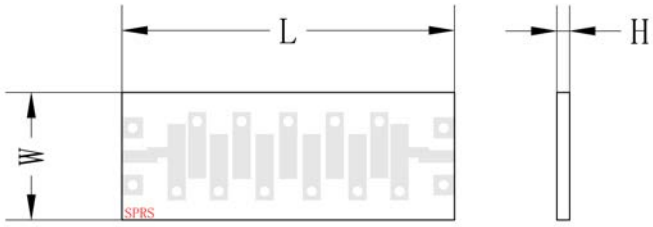
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	20.8	GHz
工作带宽	20.0-21.6	GHz
中心损耗	2.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-18.0GHz	dBc
带外抑制	40@23.3-26.0GHz	dBc

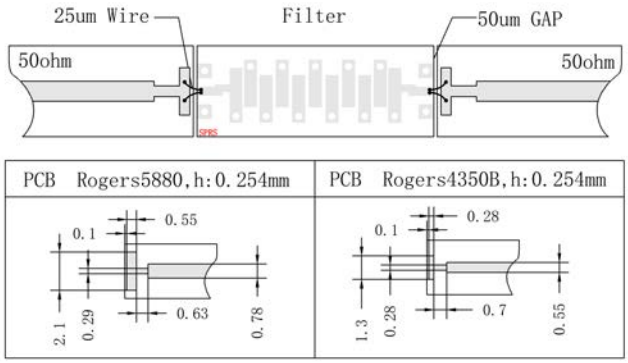
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



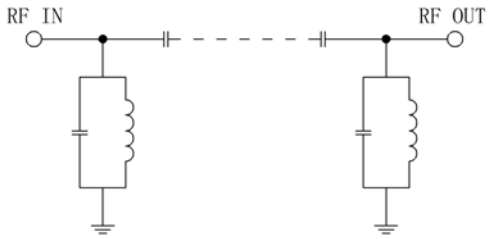
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

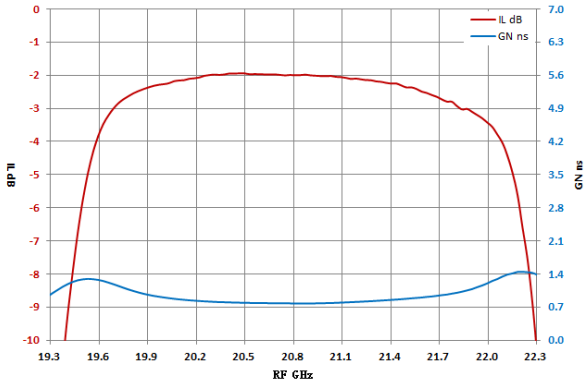
参考实物图

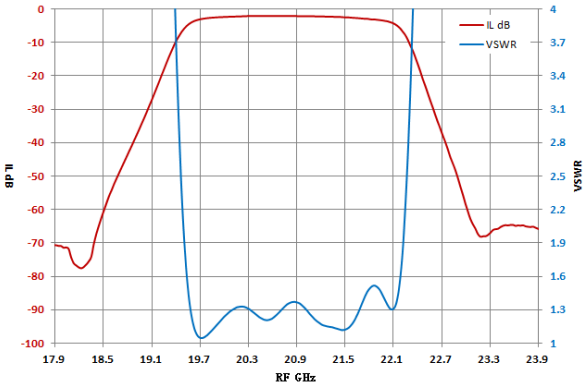


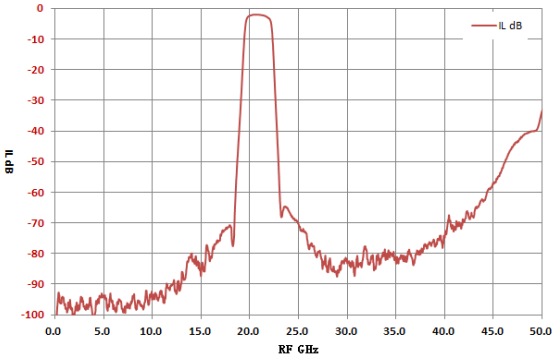
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



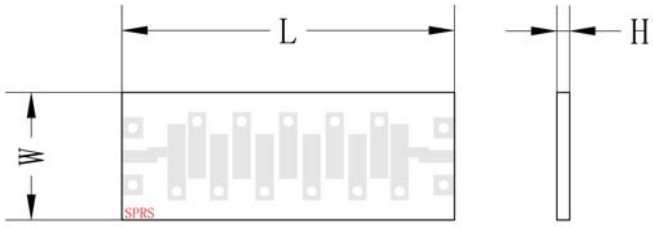
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	20.95	GHz
工作带宽	20.2-21.7	GHz
中心损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	30@DC-19.0GHz	dBc
带外抑制	40@23.3-46.0GHz	dBc

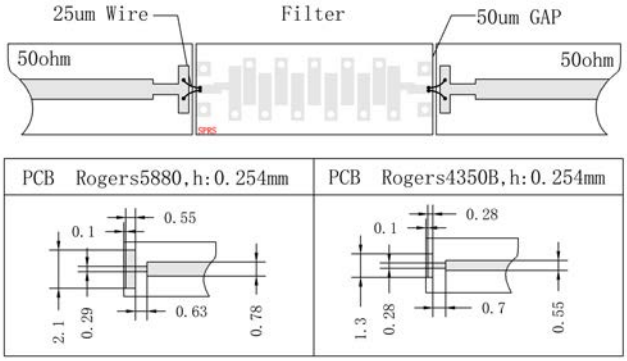
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



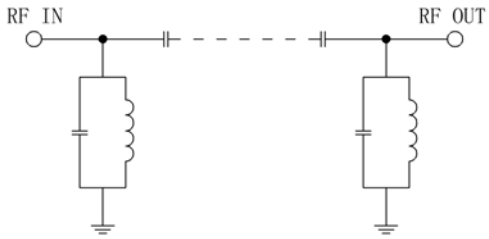
推荐装配图



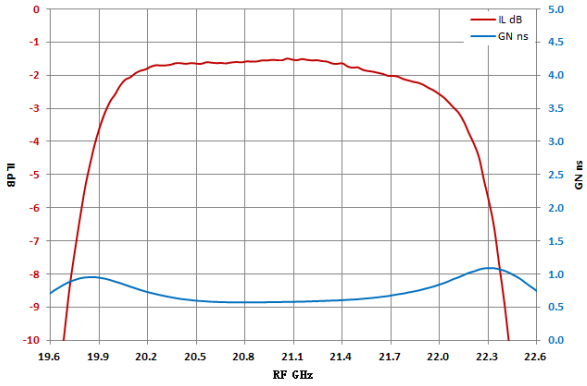
注意事项

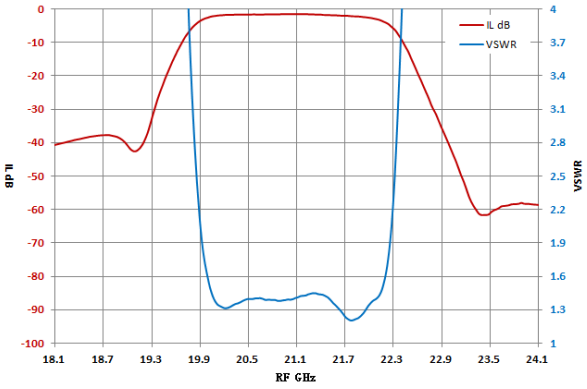
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

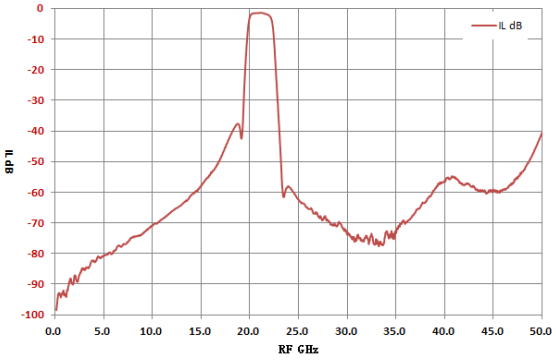
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

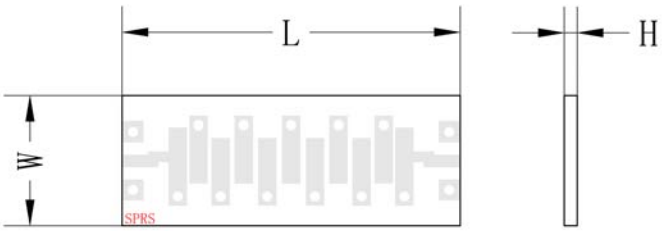
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	21.0	GHz
工作带宽	20.2-21.8	GHz
中心损耗	2.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.6	ns
带外抑制	40@DC-18.8GHz	dBc
带外抑制	40@23.0-50.0GHz	dBc

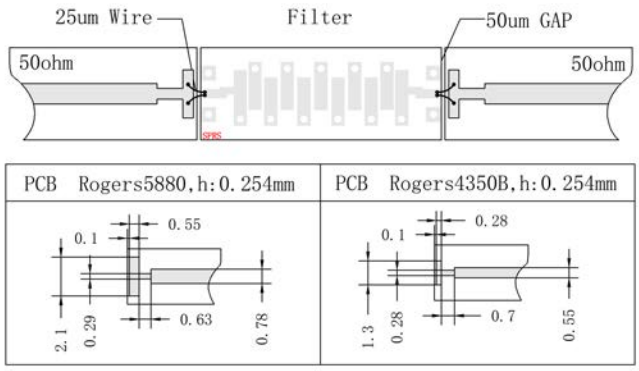
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：6.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

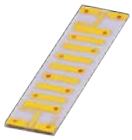
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

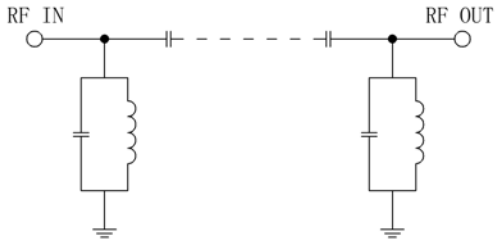
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

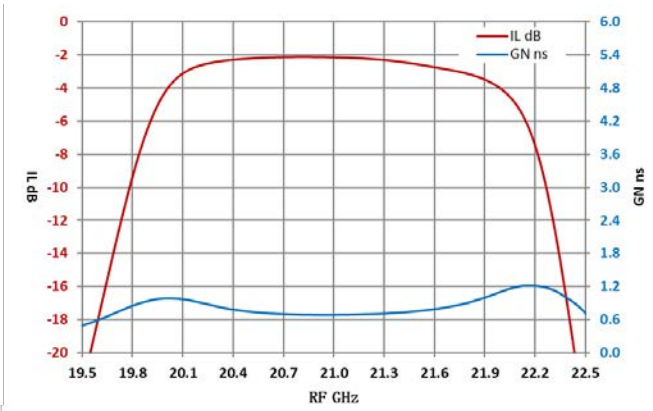
参考图

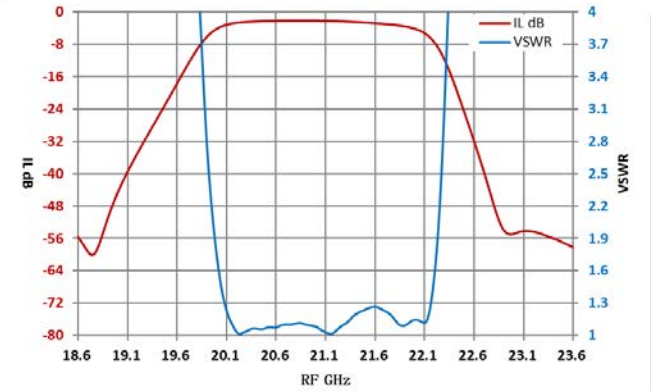


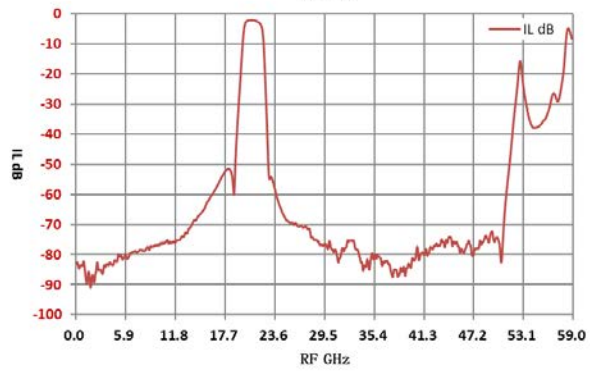
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

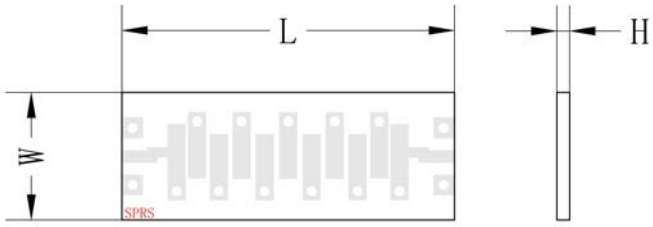
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	21.1	GHz
工作带宽	20.2-22.0	GHz
中心损耗	2.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-19.0GHz	dBc
带外抑制	40@23.5-40.0GHz	dBc

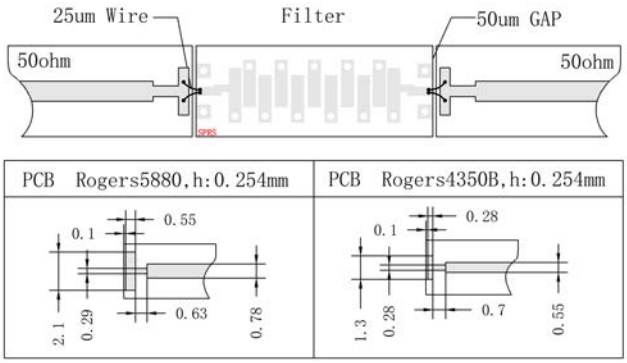
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



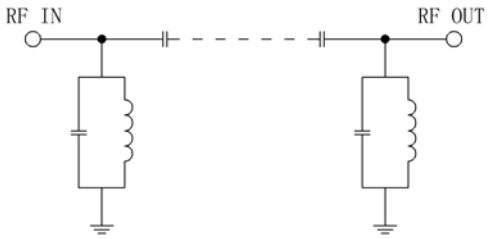
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

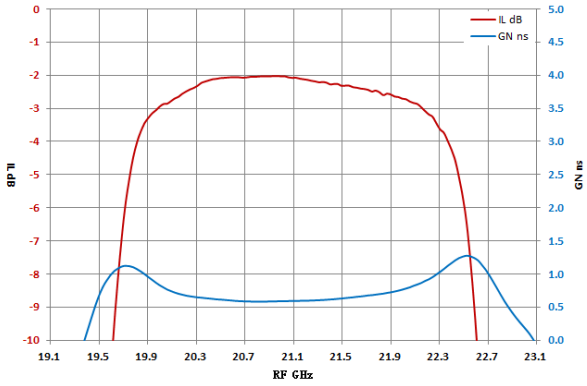
参考实物图

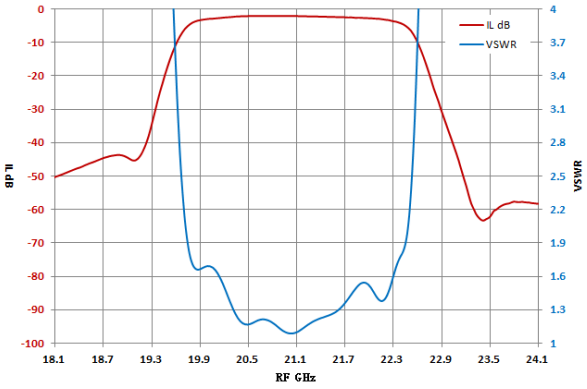


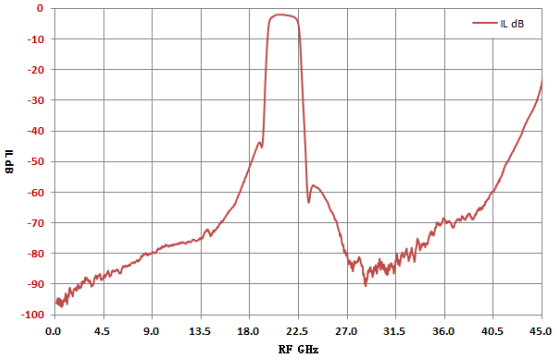
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

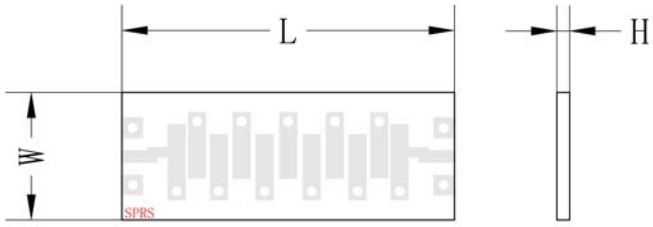
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	21.7	GHz
工作带宽	20.2-23.2	GHz
中心损耗	2.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-18.5GHz	dBc
带外抑制	40@25.1-49.0GHz	dBc

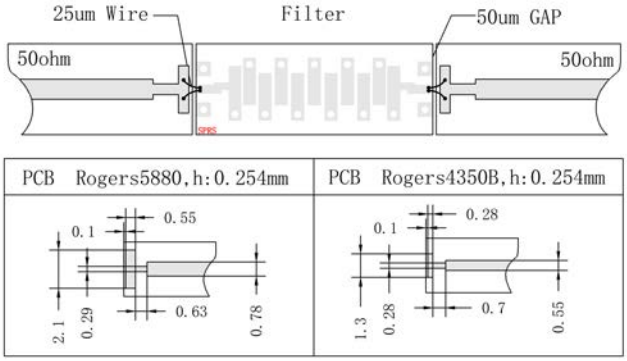
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



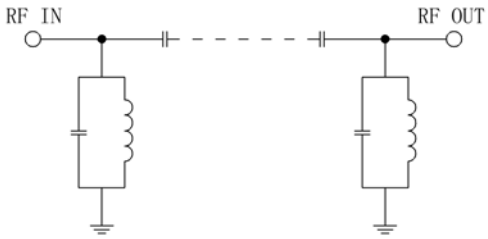
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

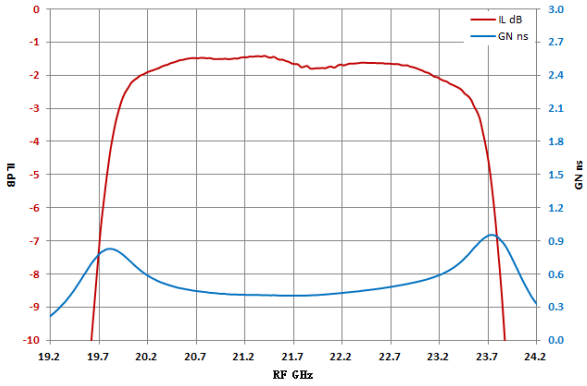
参考实物图

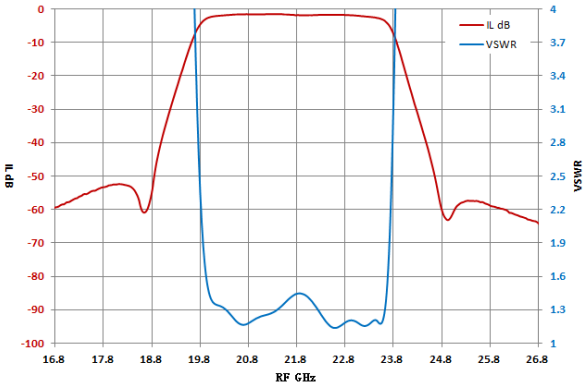


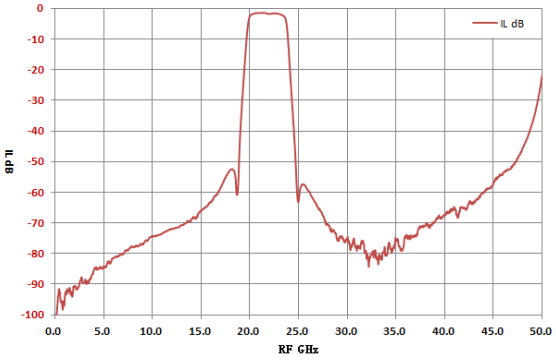
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

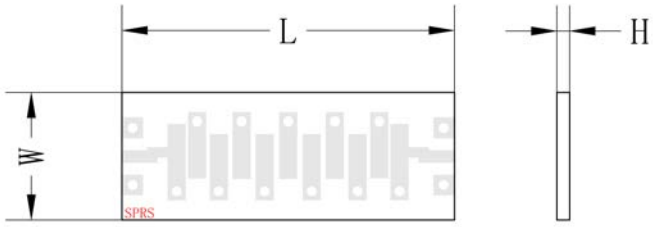
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	22.9	GHz
工作带宽	20.2-25.6	GHz
中心损耗	1.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-17.0GHz	dBc
带外抑制	40@28.2-45.0GHz	dBc

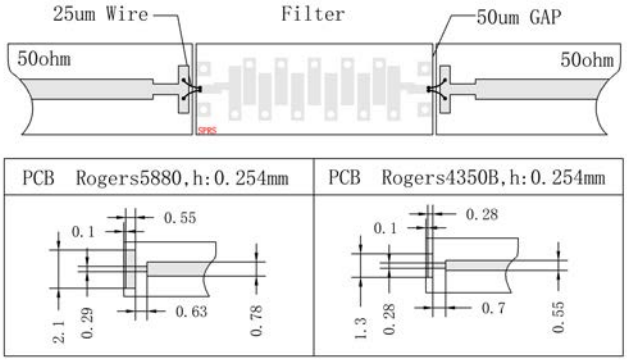
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



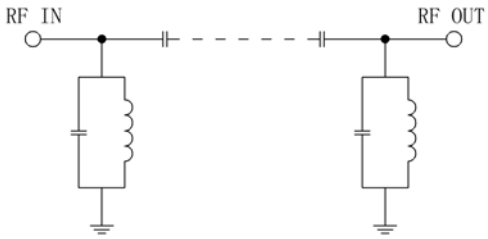
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

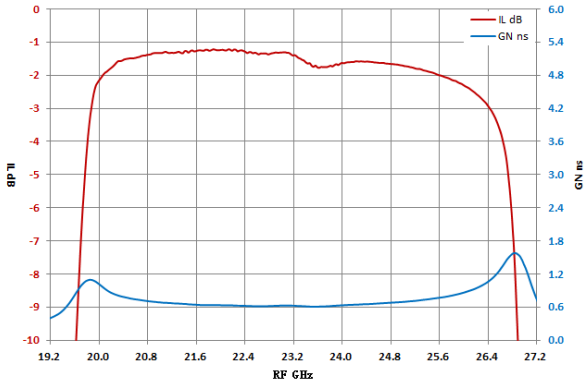
参考实物图

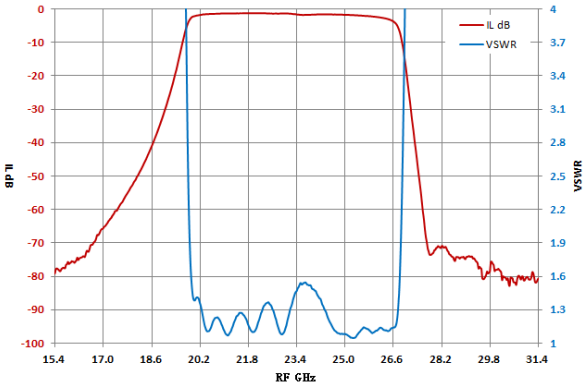


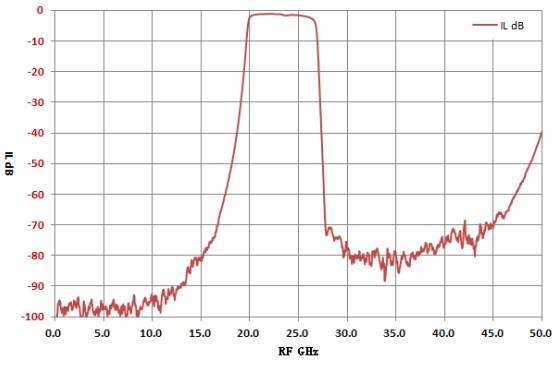
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



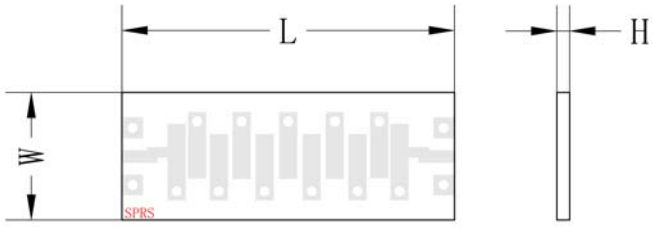
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	24.8	GHz
工作带宽	20.4-29.2	GHz
中心损耗	1.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-17.5GHz	dBc
带外抑制	40@32.8-56.0GHz	dBc

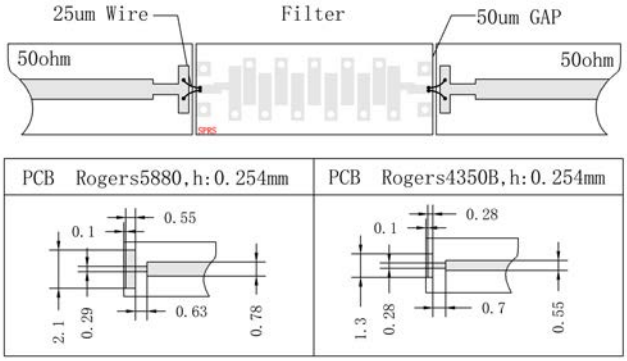
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



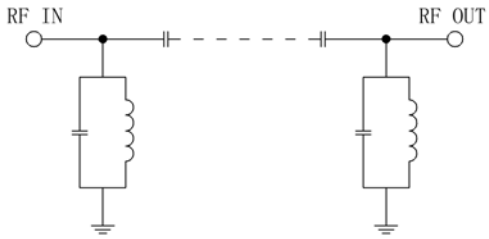
推荐装配图



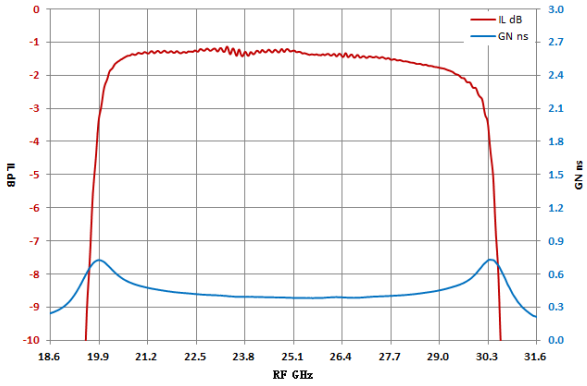
注意事项

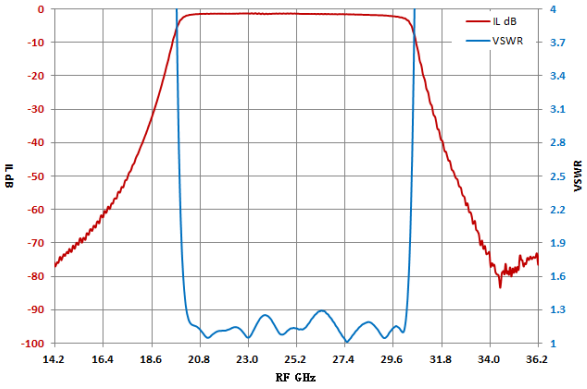
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

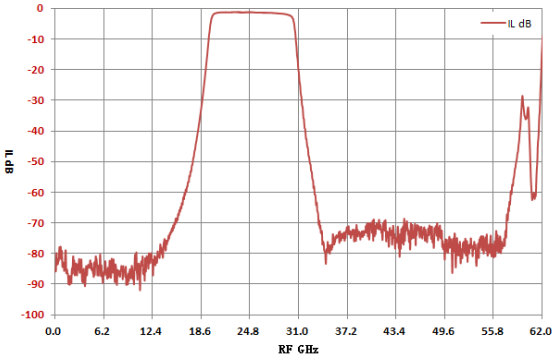
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

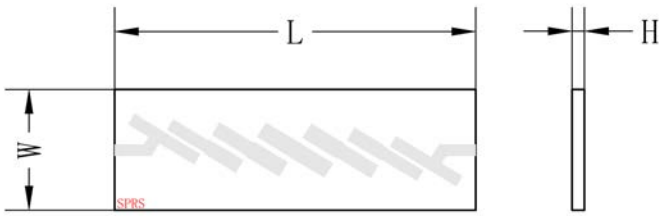
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	20.65	GHz
工作带宽	20.6-20.7	GHz
中心损耗	3.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	20@DC-19.8GHz	dBc
带外抑制	25@21.6-31.0GHz	dBc

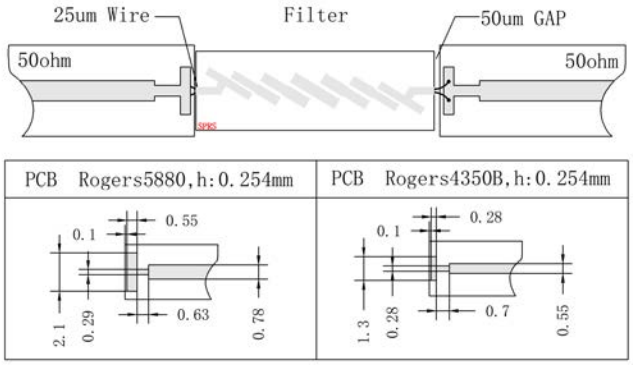
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：5.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

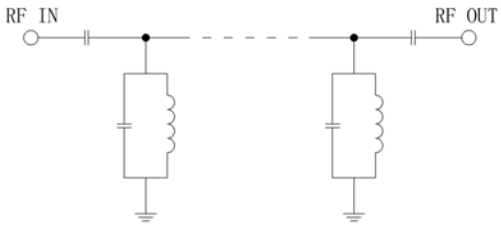
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

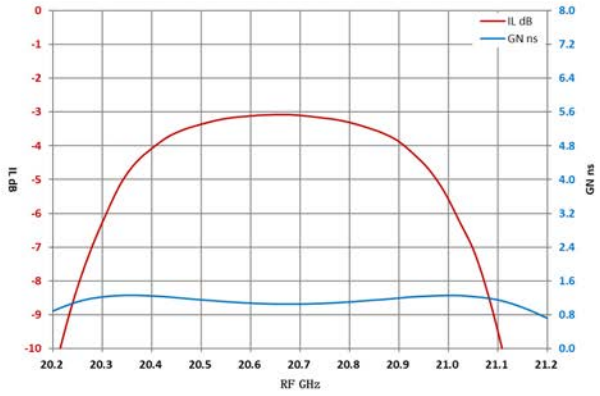
参考图

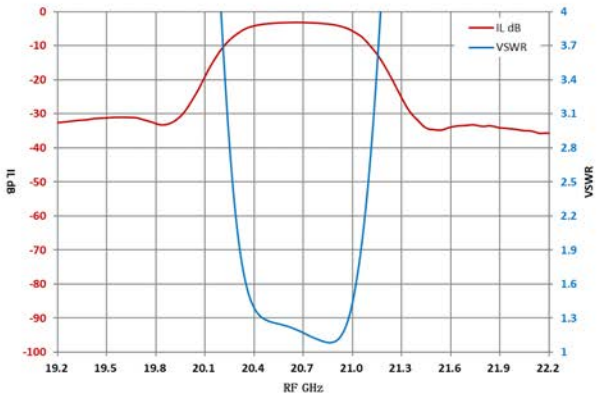


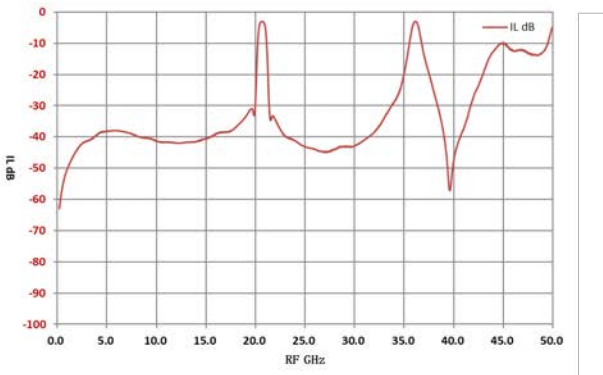
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



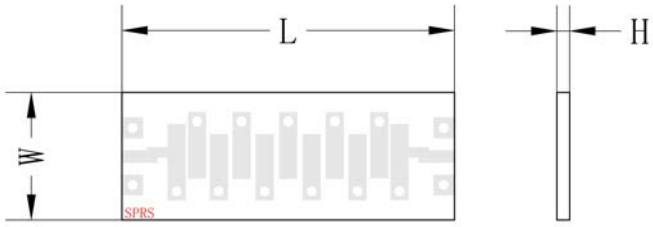
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	21.0	GHz
工作带宽	20.6-21.4	GHz
中心损耗	3.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	35@DC-18.5GHz	dBc
带外抑制	40@23.2-29.0GHz	dBc

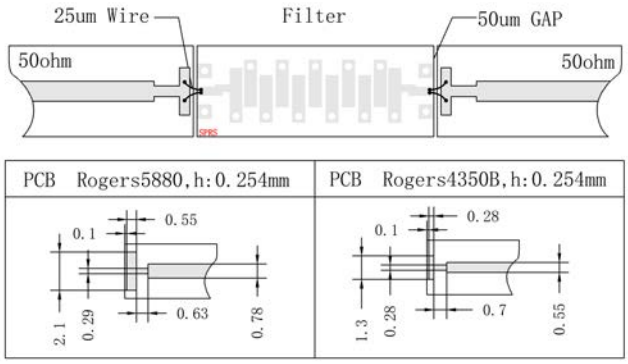
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



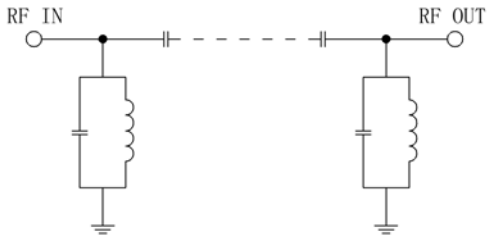
推荐装配图



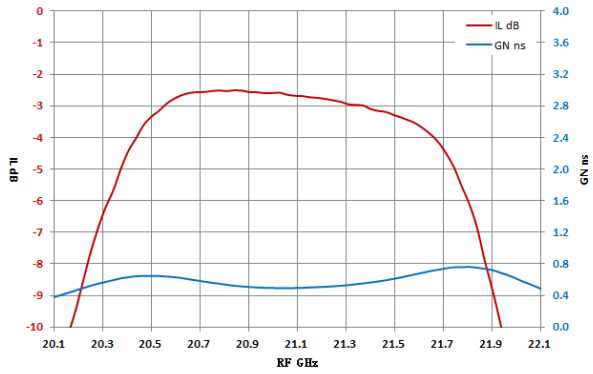
注意事项

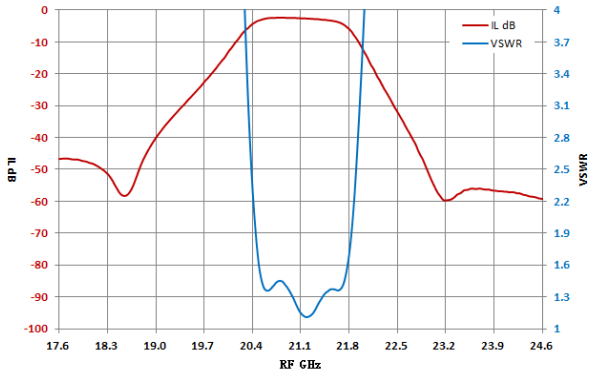
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

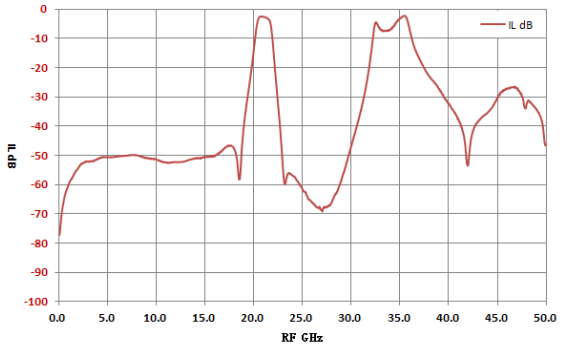
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

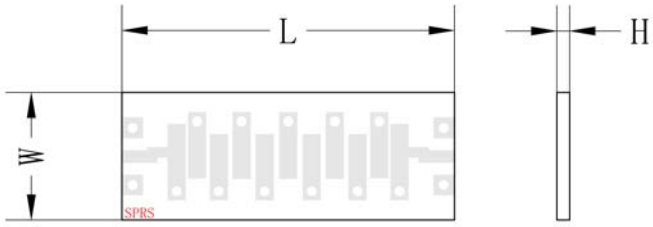
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	23.1	GHz
工作带宽	20.7-25.5	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-18.0GHz	dBc
带外抑制	40@28.4-45.0GHz	dBc

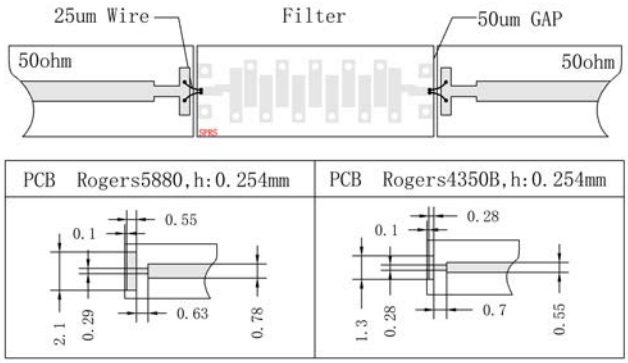
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



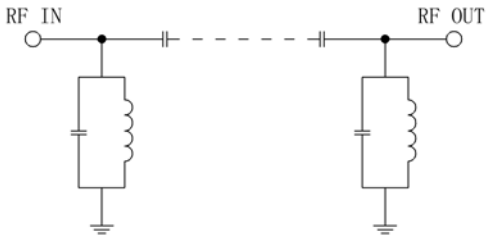
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

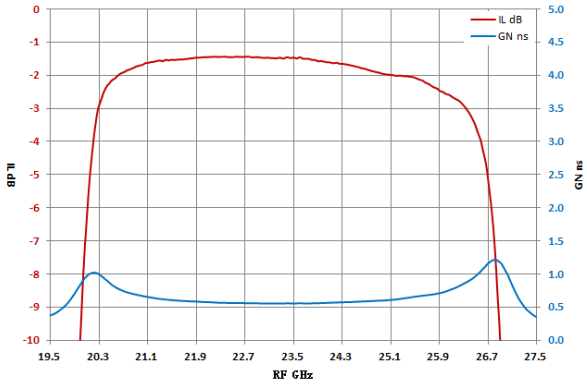
参考实物图

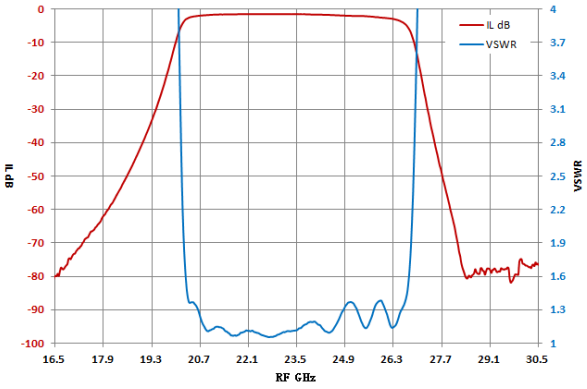


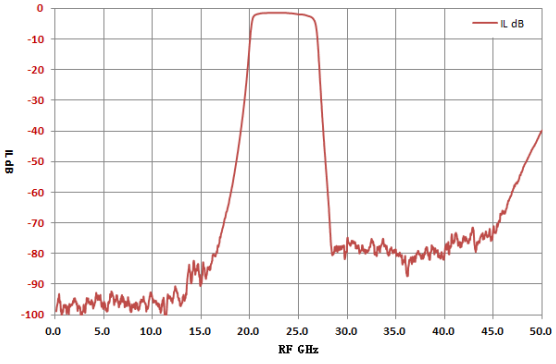
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



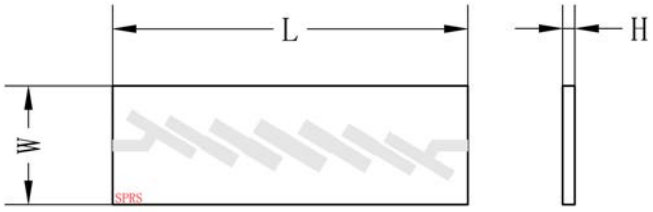
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	21.8	GHz
工作带宽	20.8-22.8	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-17.2GHz	dBc
带外抑制	40@25.0-32.0GHz	dBc

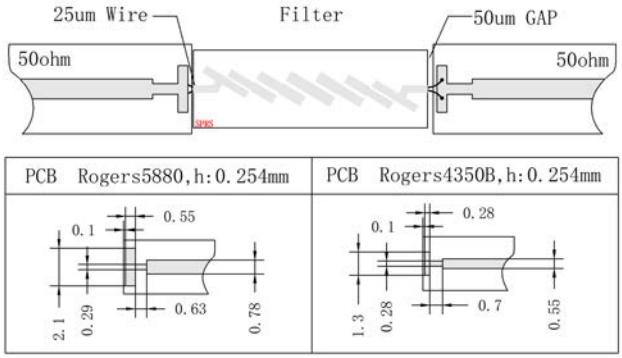
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：5.5，W：2.2，h：0.26

外形图：端口居中



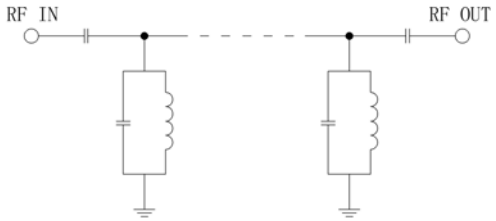
推荐装配图



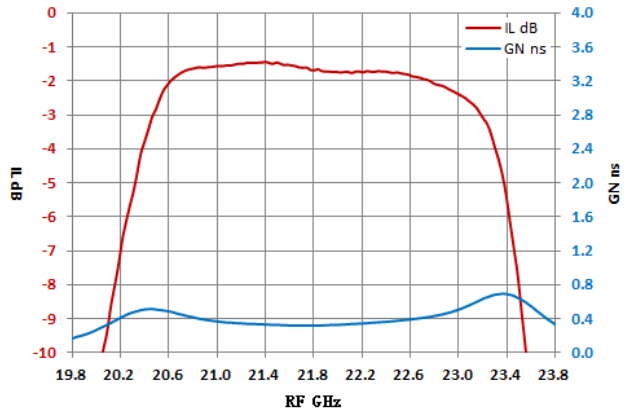
注意事项

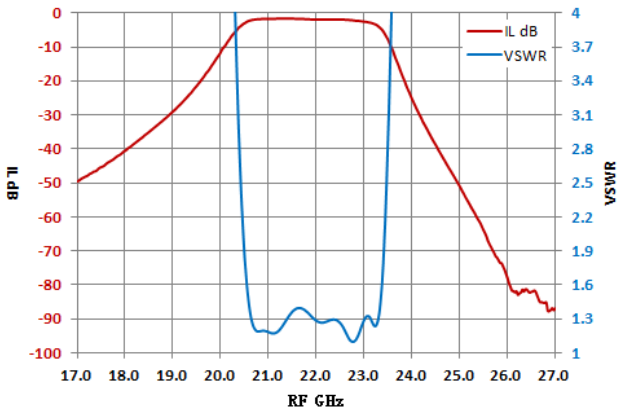
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

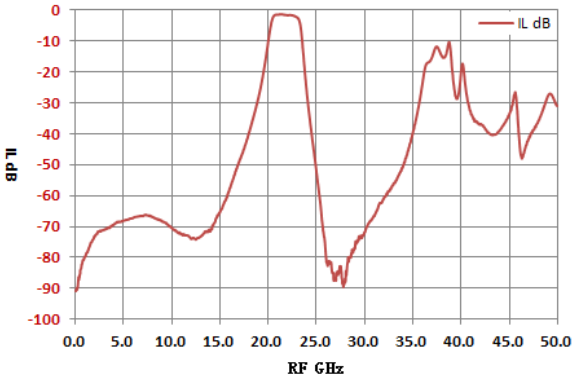
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



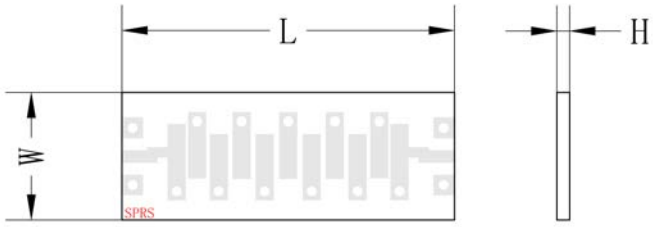
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	23.5	GHz
工作带宽	20.8-26.2	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-18.5GHz	dBc
带外抑制	40@28.5-45.0GHz	dBc

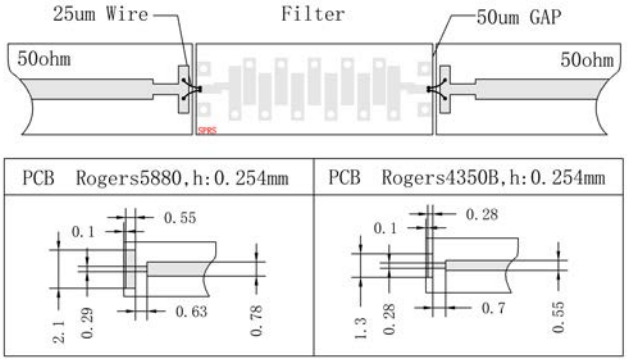
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



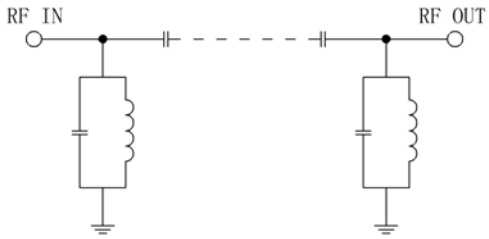
推荐装配图



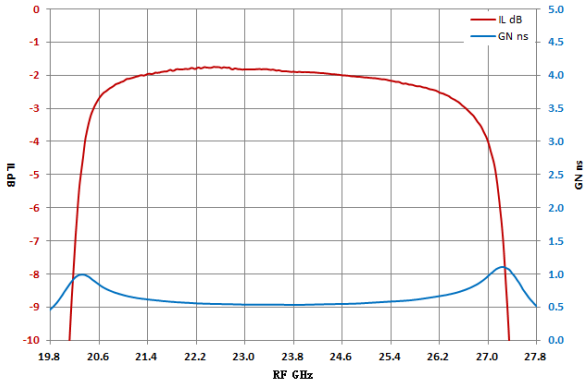
注意事项

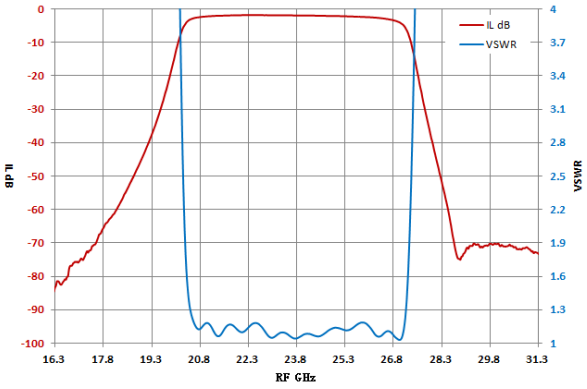
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

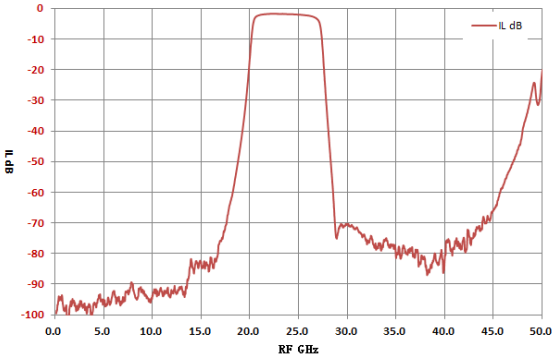
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

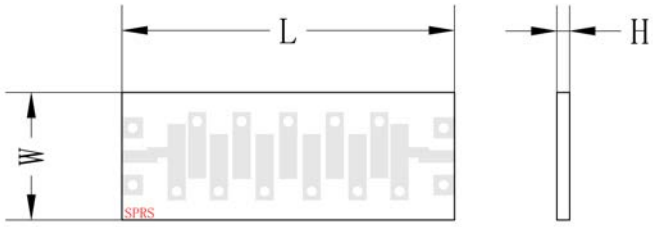
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	24.5	GHz
工作带宽	20.8-28.2	GHz
中心损耗	2.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-17.2GHz	dBc
带外抑制	40@31.2-35.0GHz	dBc

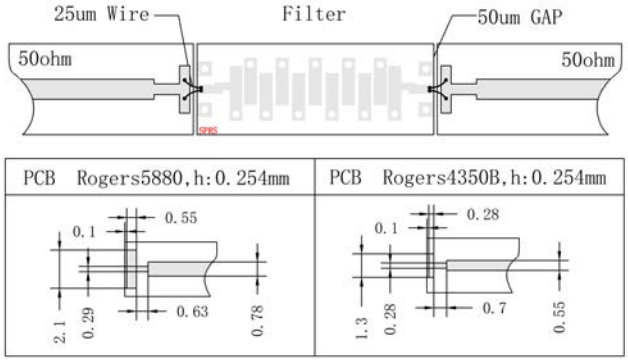
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



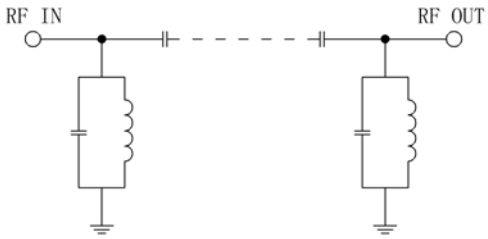
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

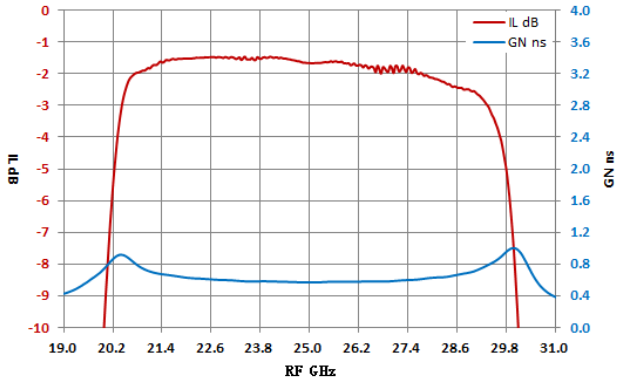
参考实物图

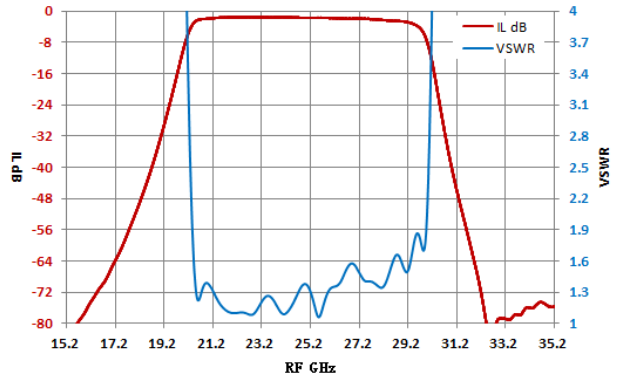


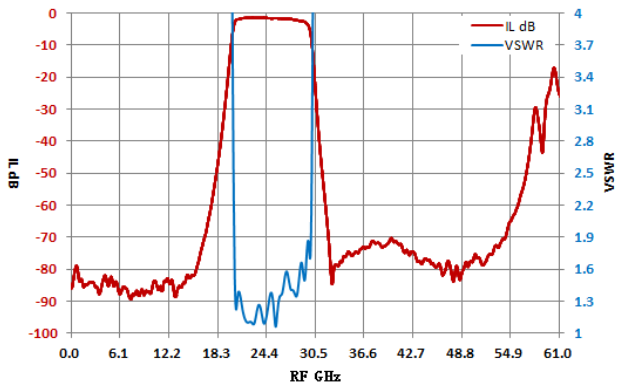
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



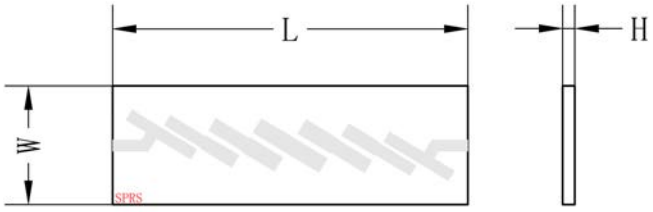
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	21.3	GHz
工作带宽	21.0-21.6	GHz
中心损耗	2.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-19.1GHz	dBc
带外抑制	35@23.5-29.0GHz	dBc

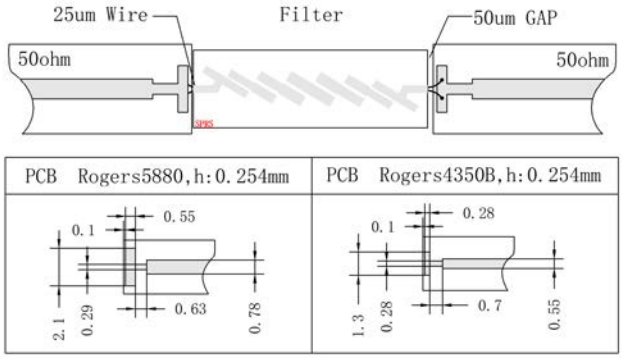
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



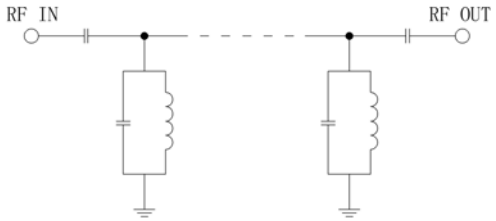
推荐装配图



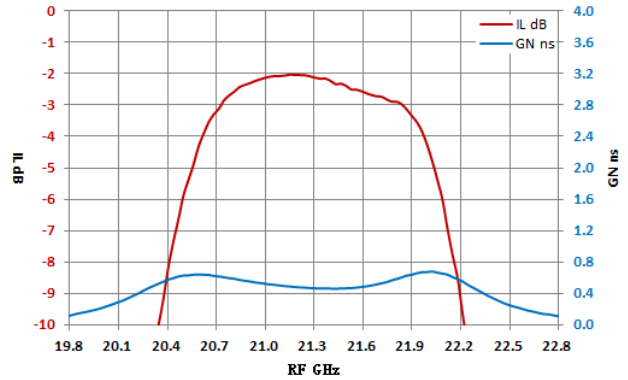
注意事项

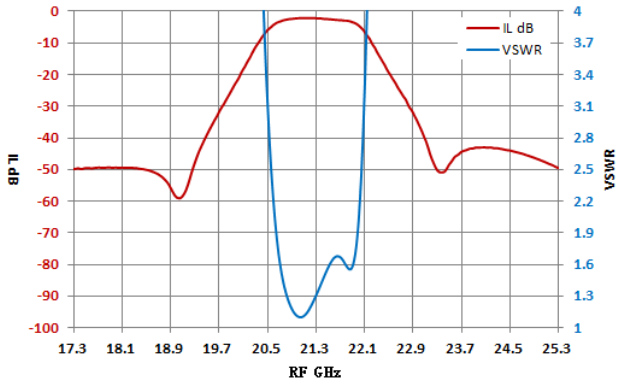
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

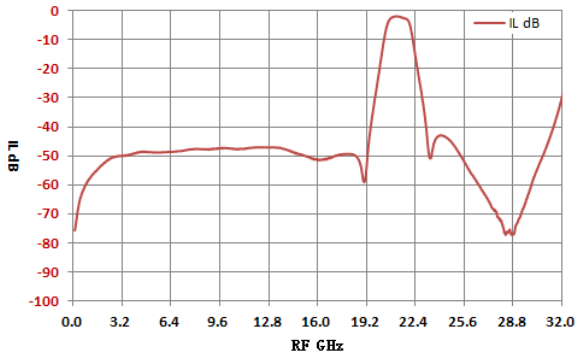
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

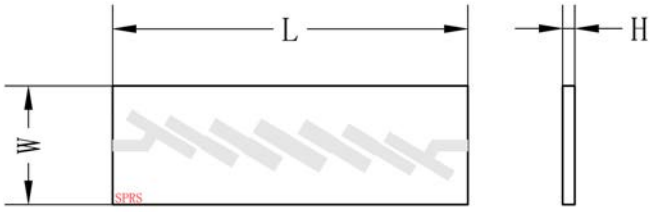
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	21.8	GHz
工作带宽	21.0-22.6	GHz
中心损耗	2.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-19.3GHz	dBc
带外抑制	40@24.1-36.0GHz	dBc

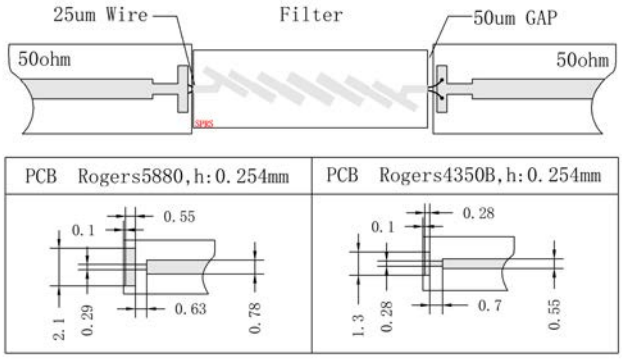
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



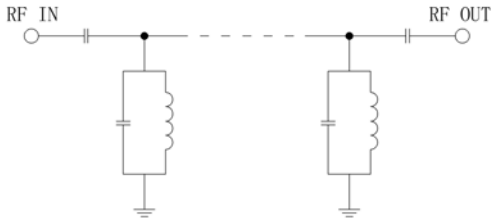
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

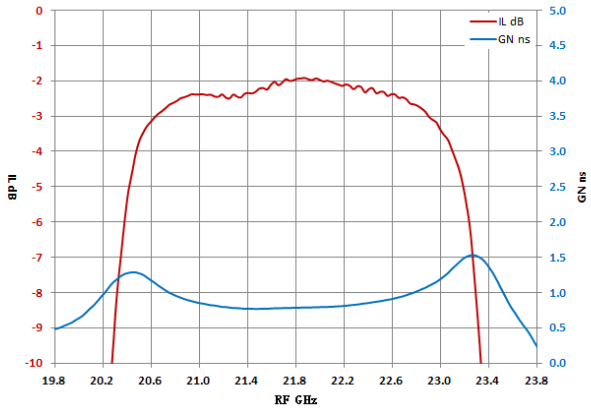
参考实物图

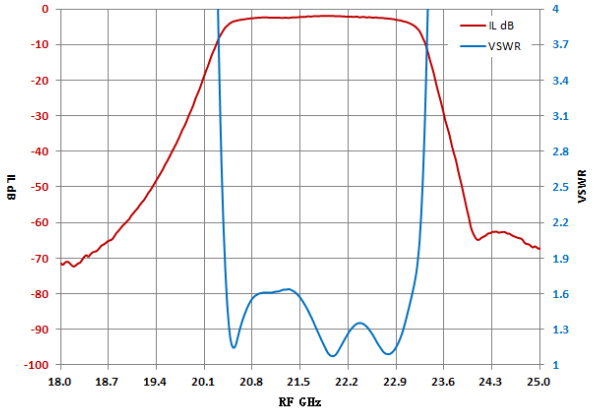


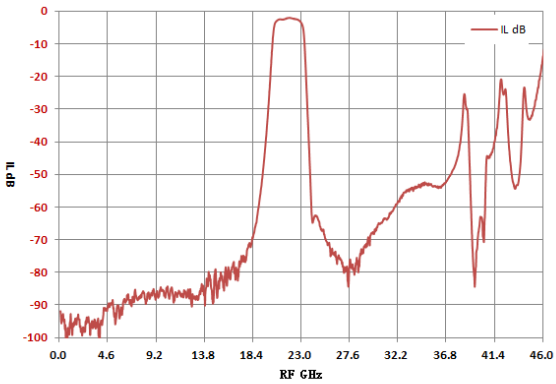
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

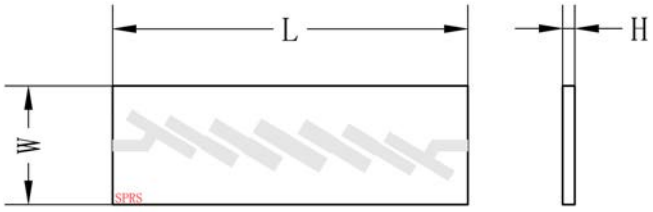
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	22.6	GHz
工作带宽	21.0-24.2	GHz
中心损耗	1.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-19.1GHz	dBc
带外抑制	40@26.9-33.0GHz	dBc

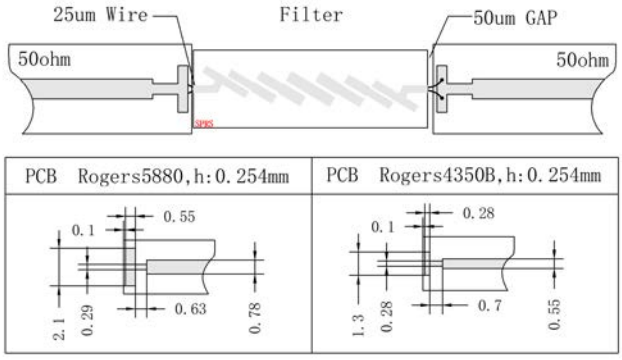
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



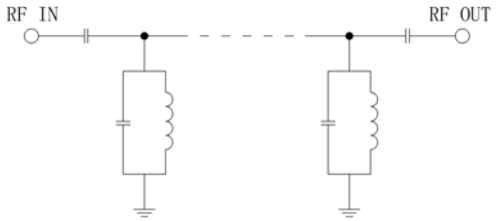
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

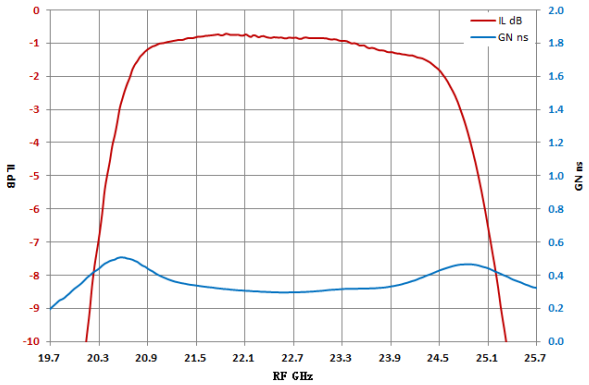
参考实物图

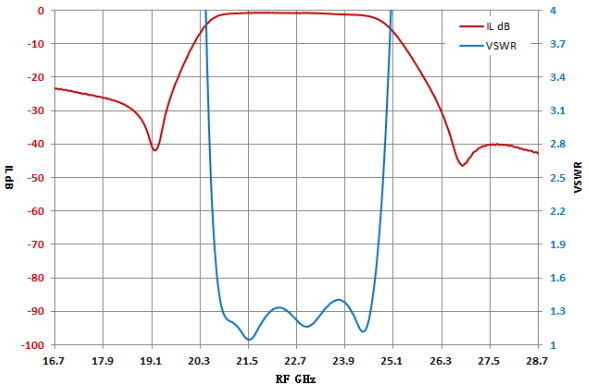


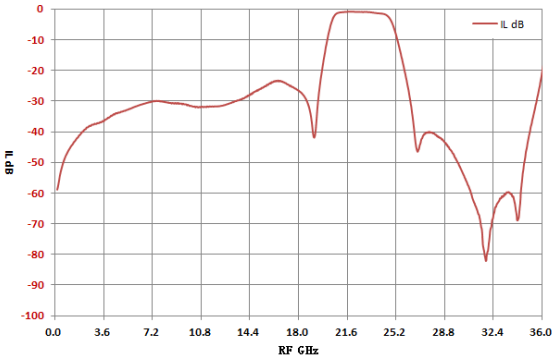
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



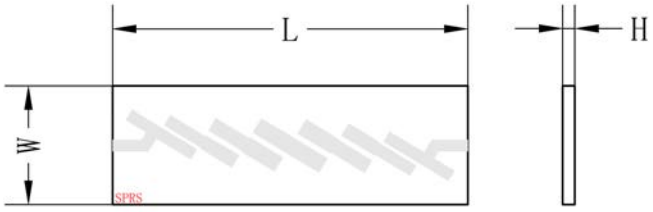
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	23.9	GHz
工作带宽	21.0-26.8	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-18.7GHz	dBc
带外抑制	40@30.5-41.0GHz	dBc

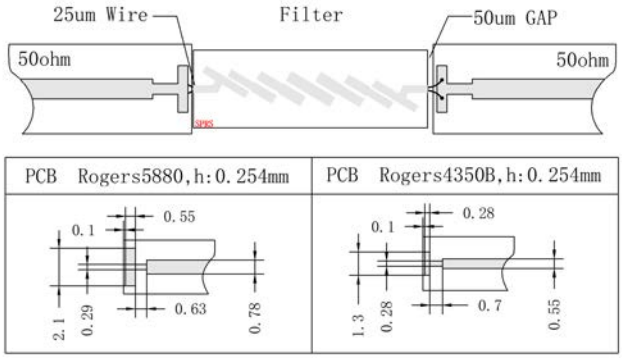
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：10.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



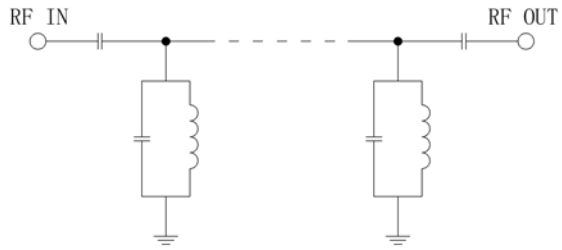
推荐装配图



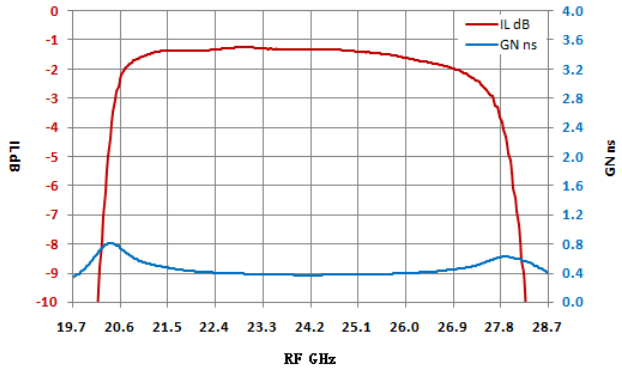
注意事项

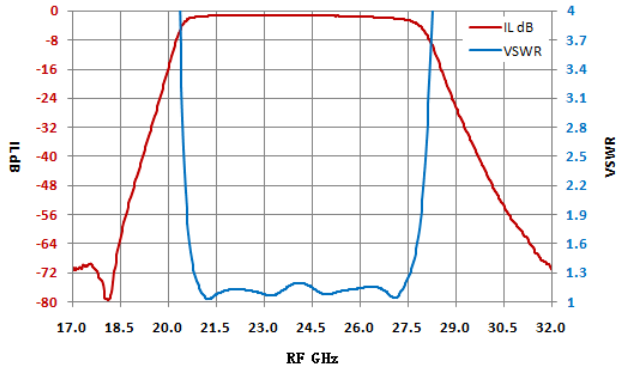
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

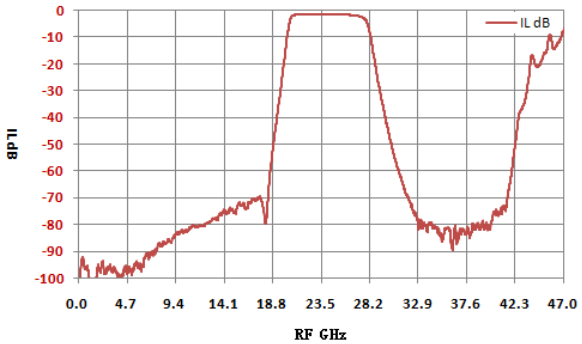
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

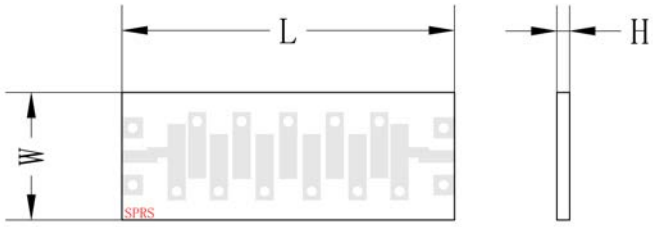
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	24.5	GHz
工作带宽	21.0-28.0	GHz
中心损耗	1.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-18.2GHz	dBc
带外抑制	40@30.9-48.0GHz	dBc

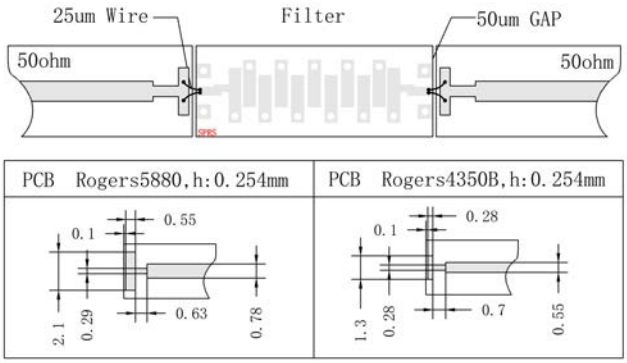
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



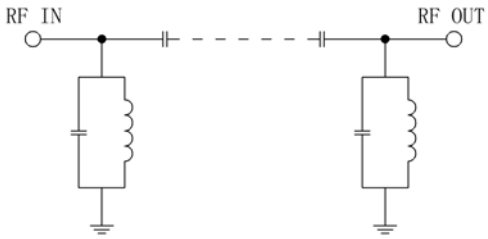
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

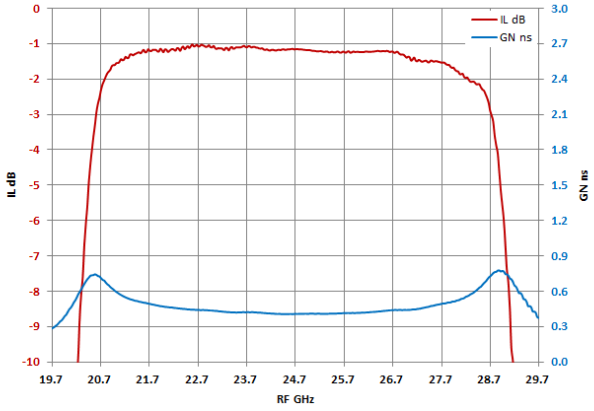
参考实物图

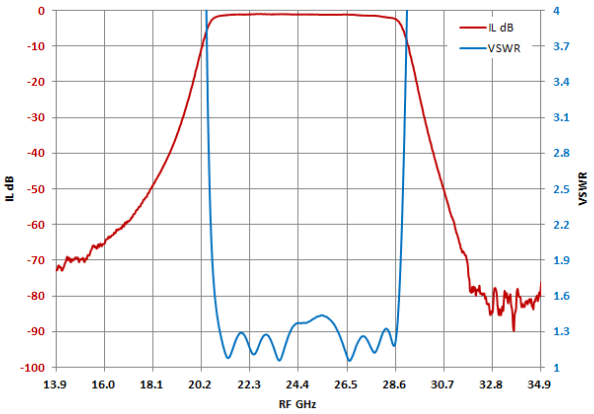


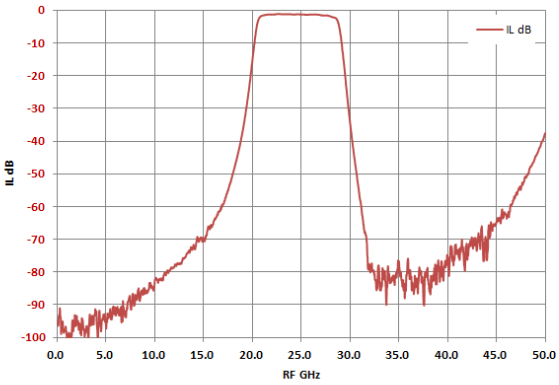
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

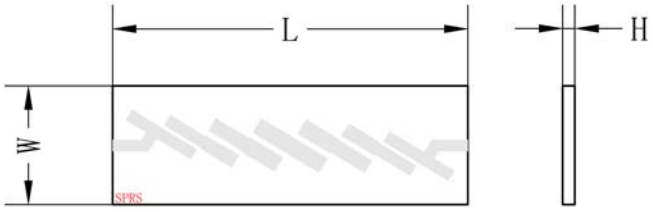
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	21.5	GHz
工作带宽	21.1-21.9	GHz
中心损耗	3.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-20.0GHz	dBc
带外抑制	40@23.1-36.0GHz	dBc

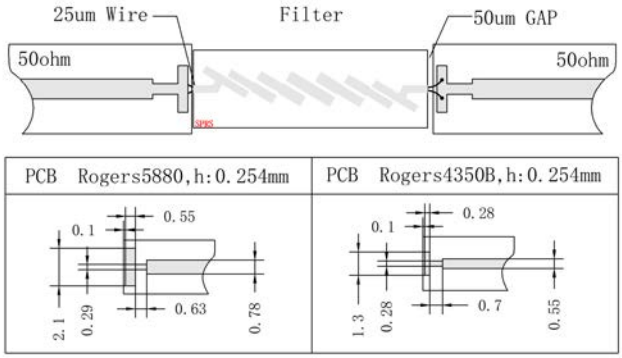
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：11.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



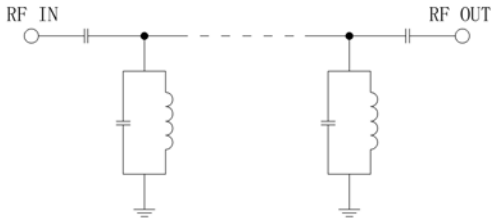
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

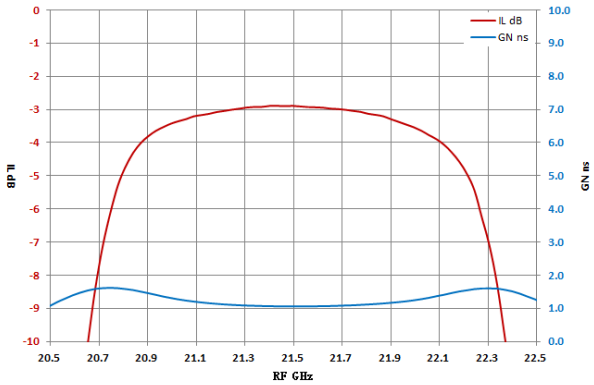
参考实物图

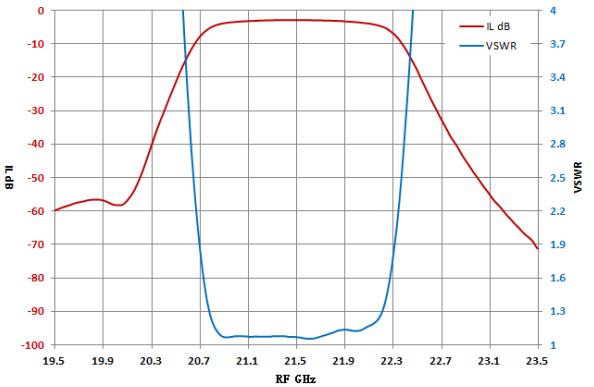


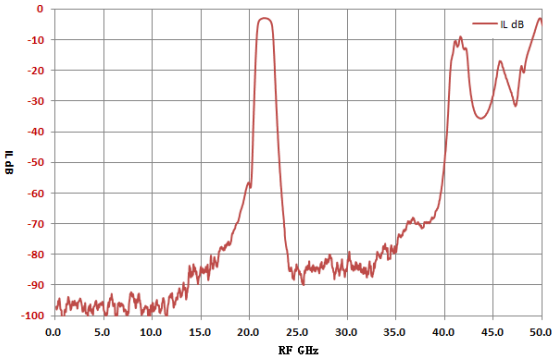
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



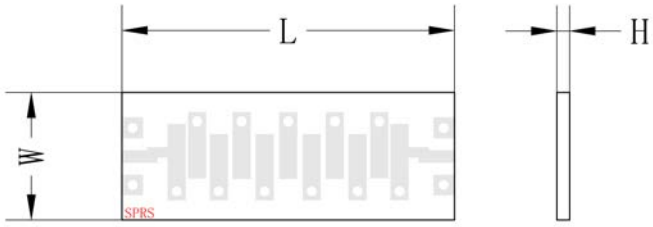
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	21.8	GHz
工作带宽	21.2-22.4	GHz
中心损耗	3.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-19.8GHz	dBc
带外抑制	40@24.0-31.0GHz	dBc

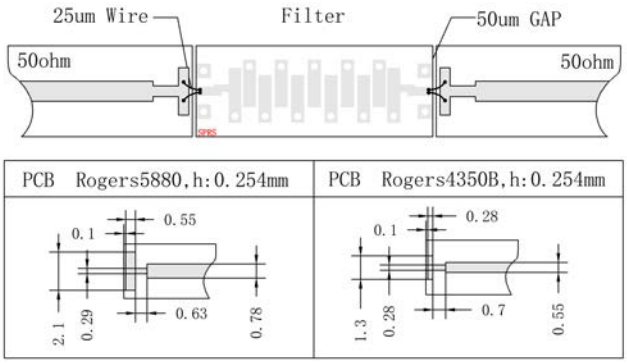
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



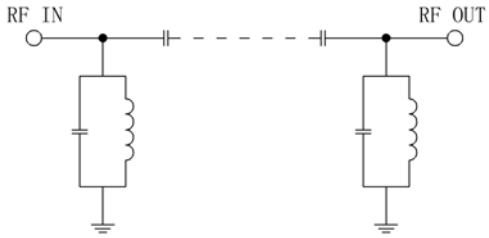
推荐装配图



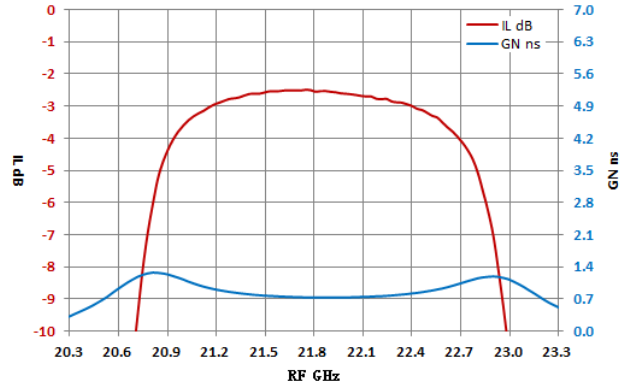
注意事项

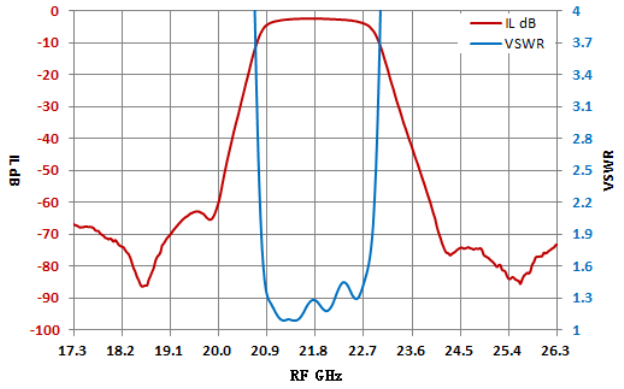
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

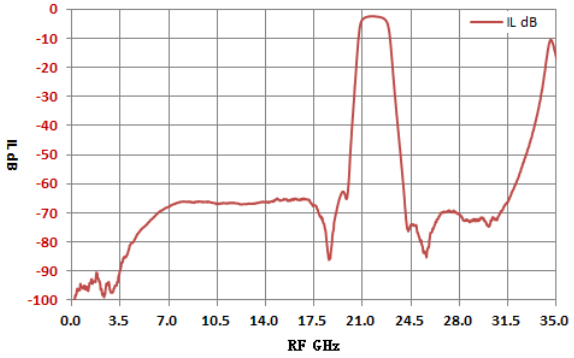
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

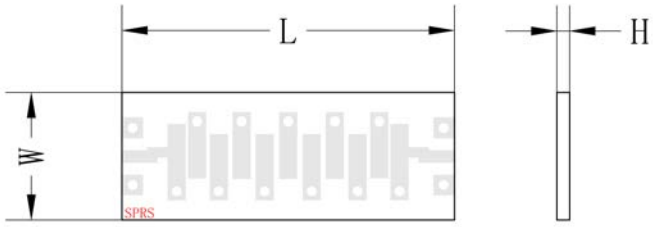
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	22	GHz
工作带宽	21.2-22.8	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-19.6GHz	dBc
带外抑制	40@24.2-26.0GHz	dBc

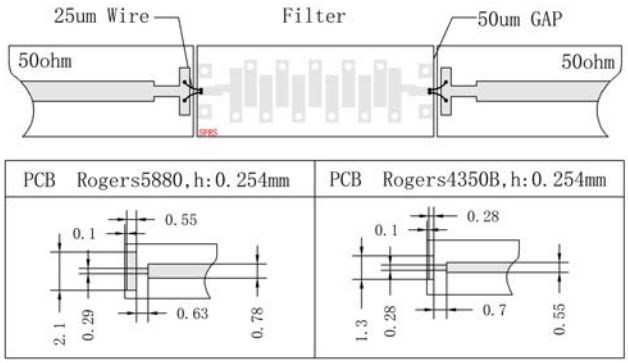
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



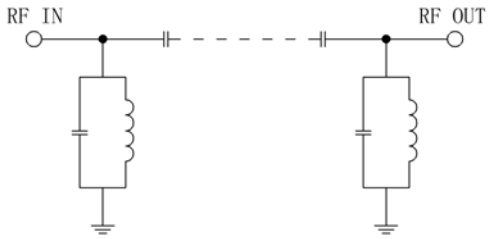
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

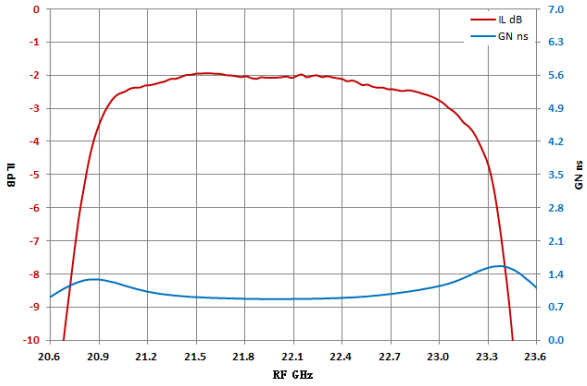
参考实物图

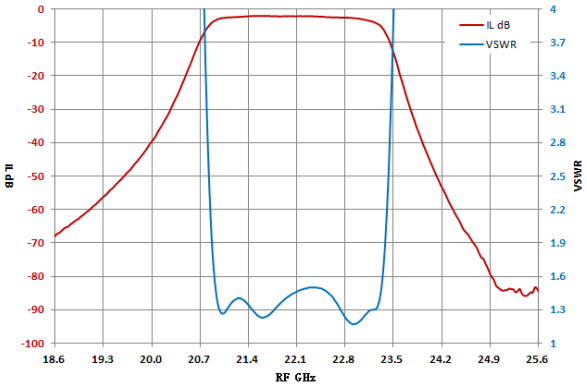


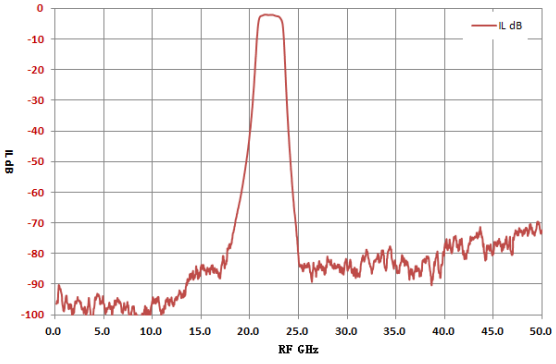
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



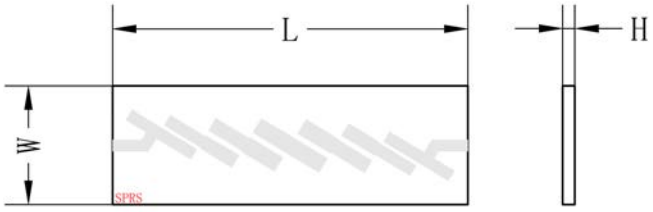
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	22.6	GHz
工作带宽	21.2-24.0	GHz
中心损耗	2.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	25@DC-19.7GHz	dBc
带外抑制	30@26.0-33.0GHz	dBc

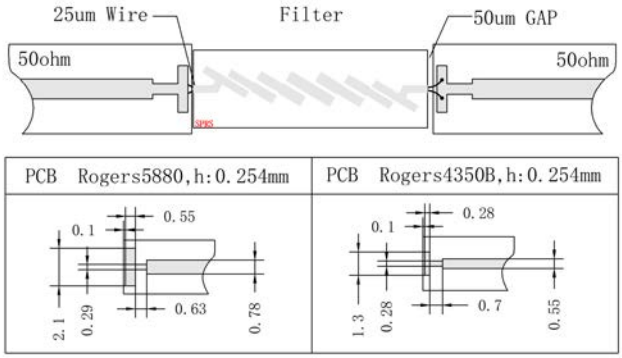
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



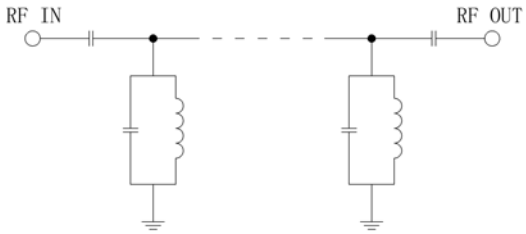
推荐装配图



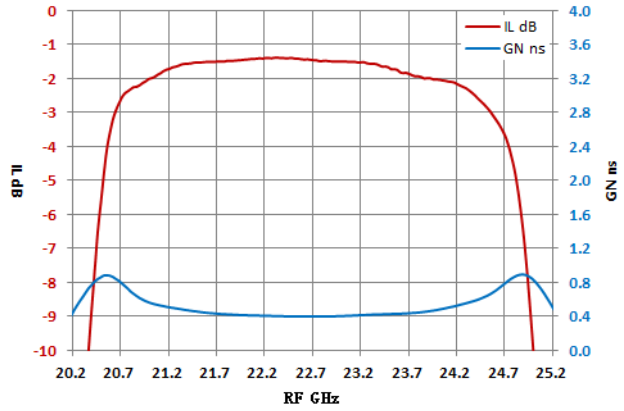
注意事项

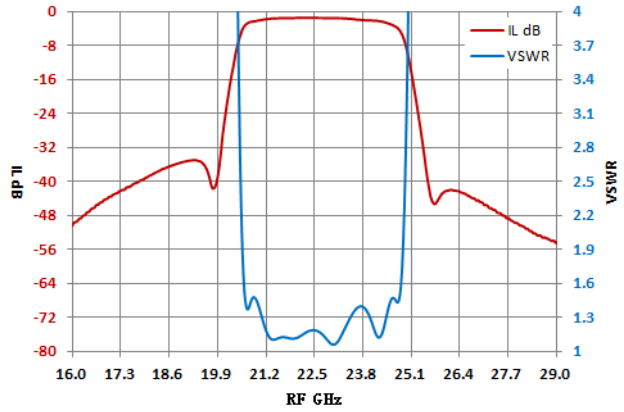
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

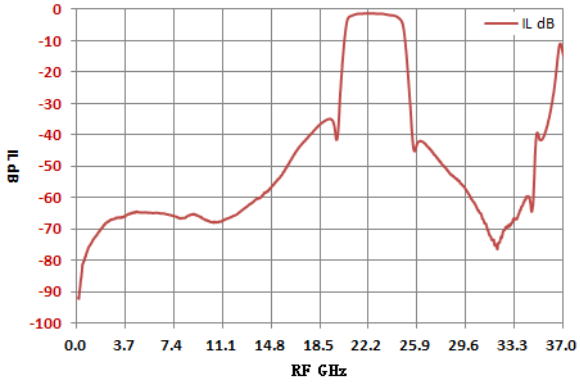
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



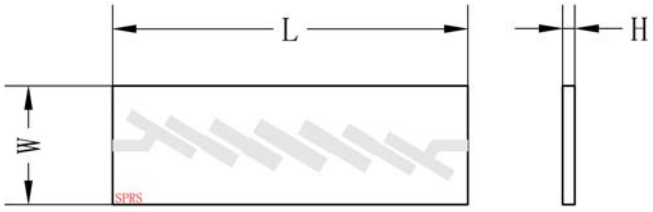
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	21.9	GHz
工作带宽	21.3-22.5	GHz
中心损耗	2.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-19.7GHz	dBc
带外抑制	40@24.0-30.0GHz	dBc

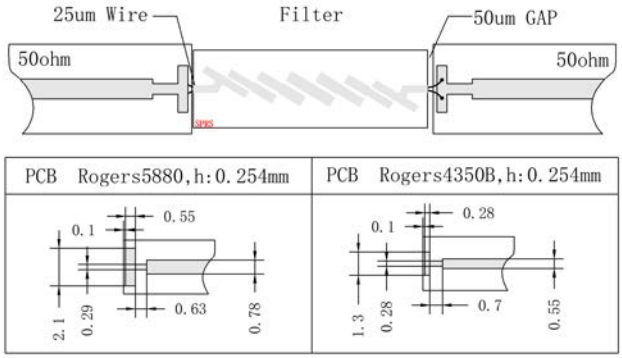
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



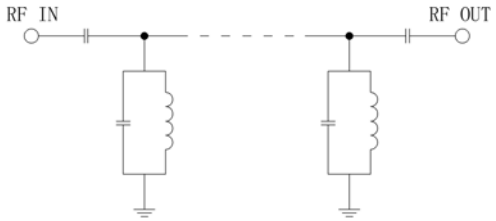
推荐装配图



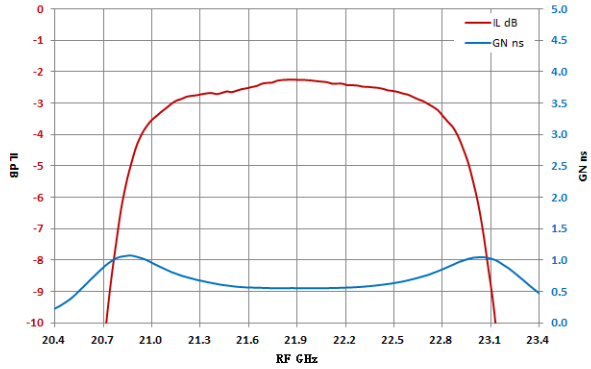
注意事项

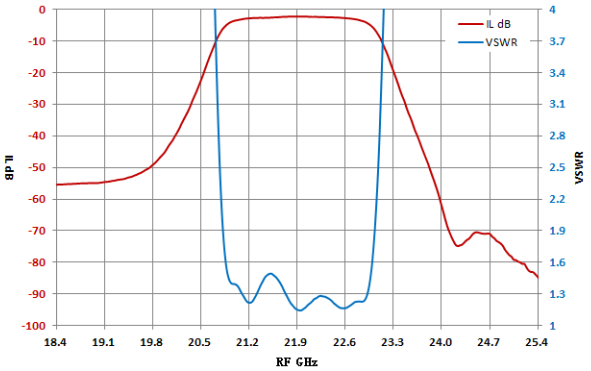
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

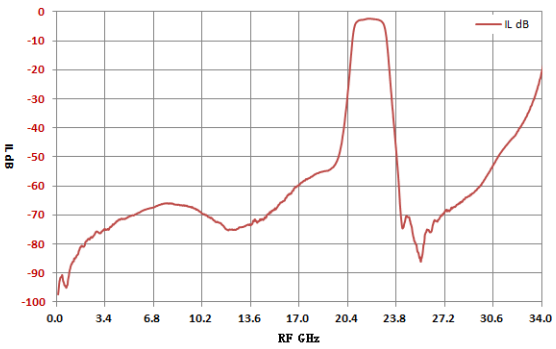
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

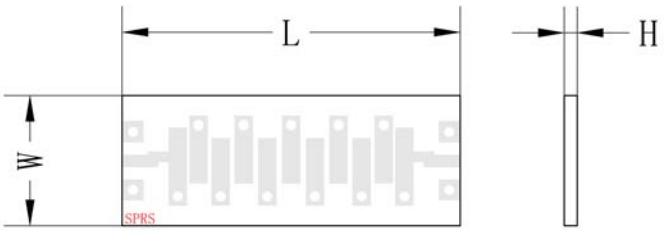
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	22.1	GHz
工作带宽	21.4-22.8	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-19.0GHz	dBc
带外抑制	40@24.6-46.0GHz	dBc

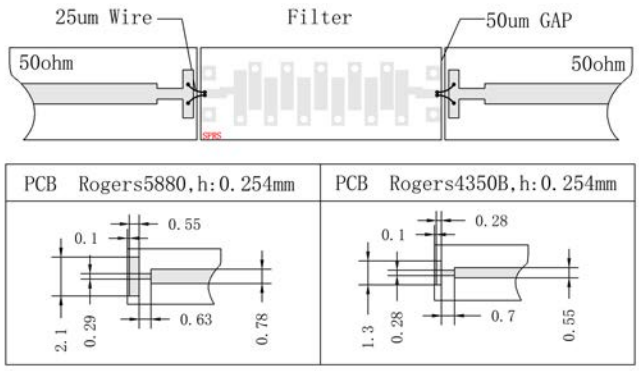
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.74mm,端口可互换;

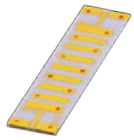
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

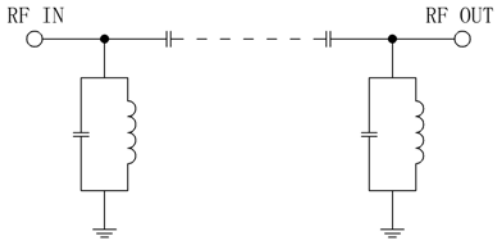
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

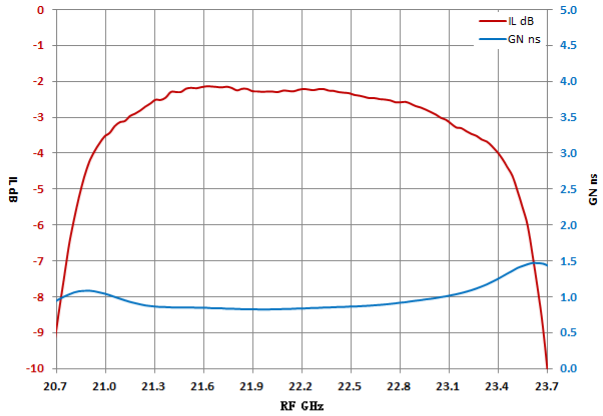
参考图

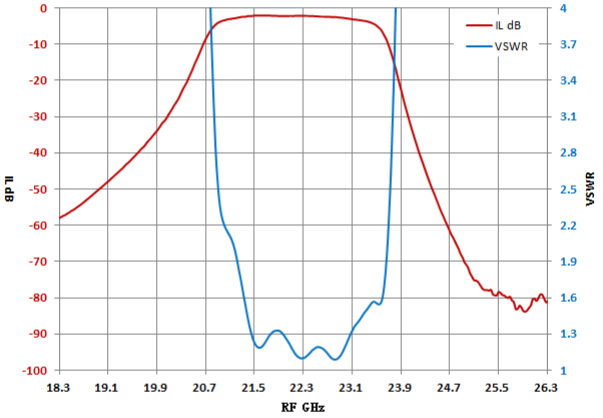


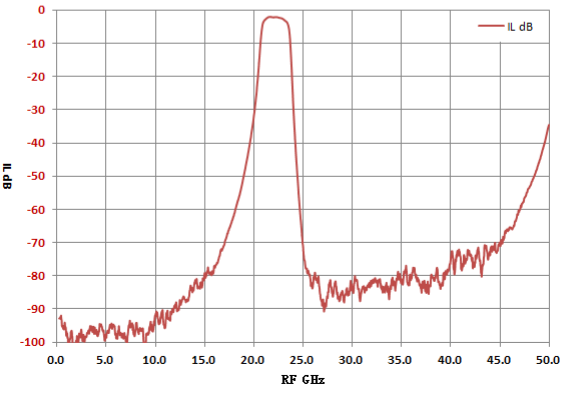
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

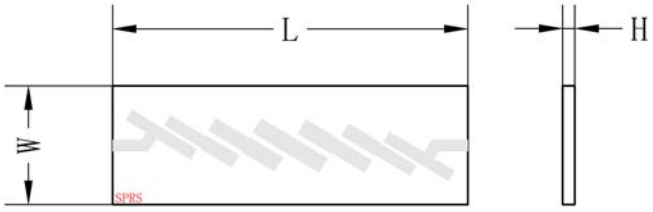
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	22.7	GHz
工作带宽	21.4-24.0	GHz
中心损耗	1.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-19.5GHz	dBc
带外抑制	40@25.6-33.0GHz	dBc

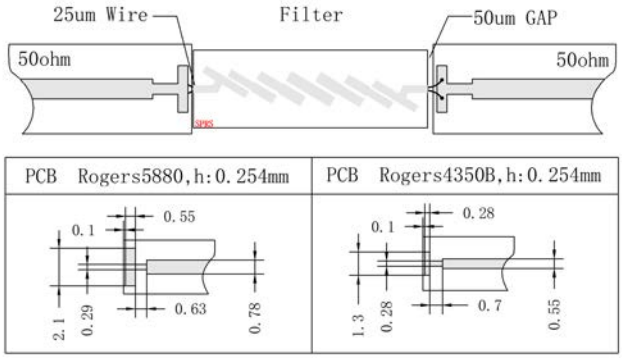
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



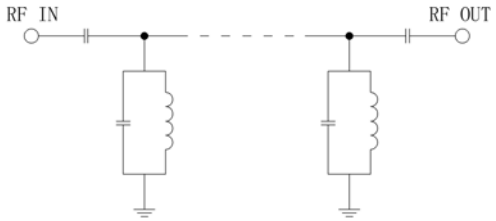
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

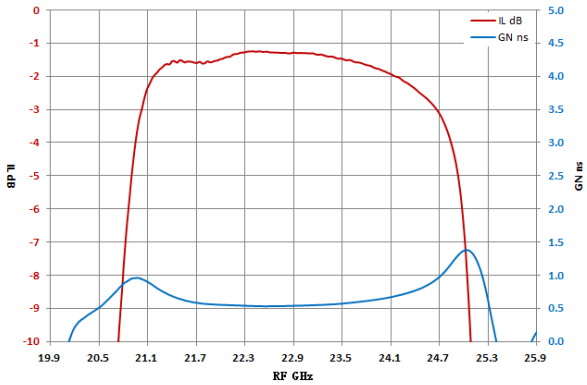
参考实物图

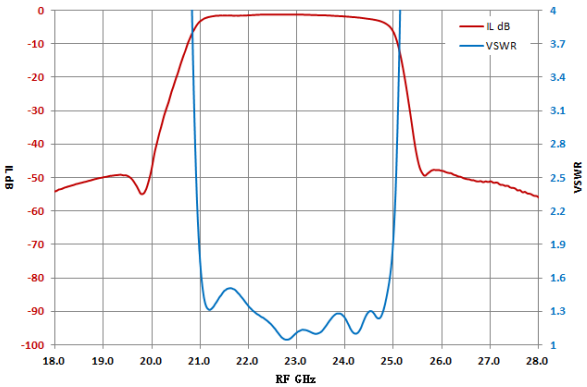


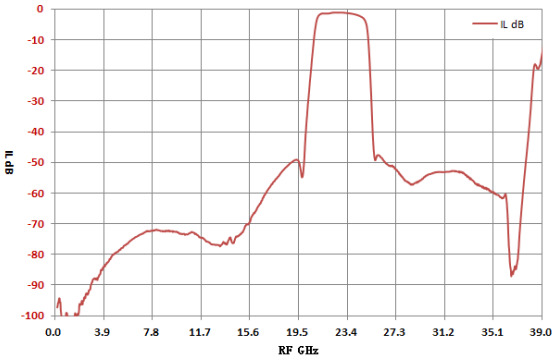
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

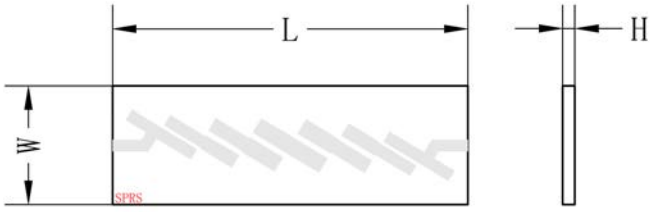
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	23.3	GHz
工作带宽	21.4-25.2	GHz
中心损耗	1.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-15.6GHz	dBc
带外抑制	40@28.4-32.0GHz	dBc

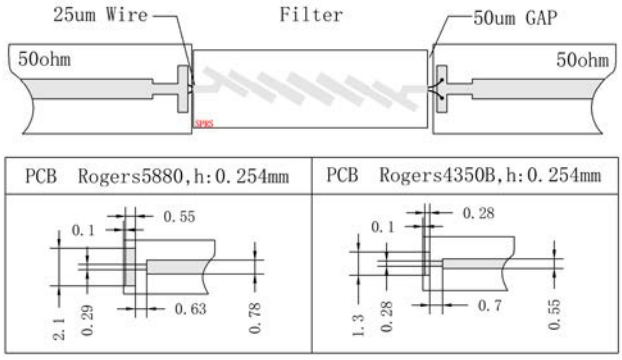
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：5.5，W：2.5，h：0.39

外形图：端口居中



推荐装配图



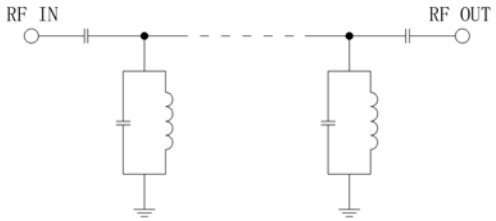
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.61mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

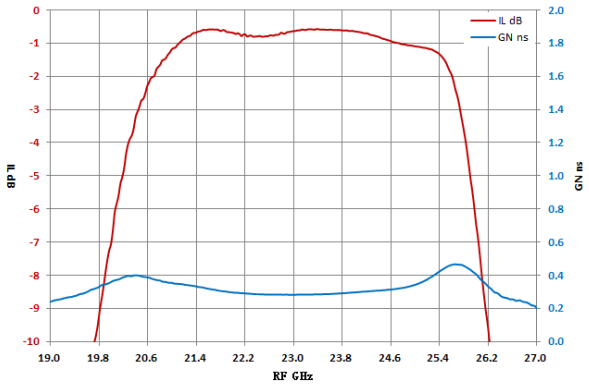
参考实物图

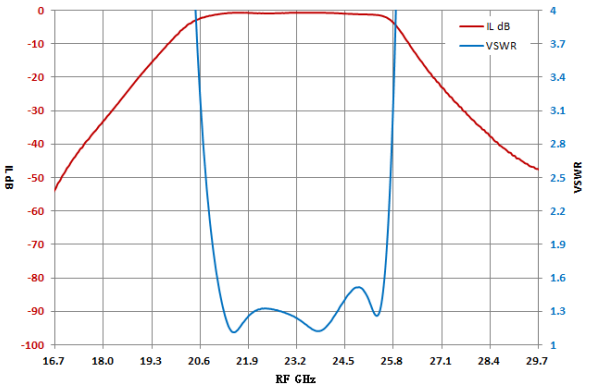


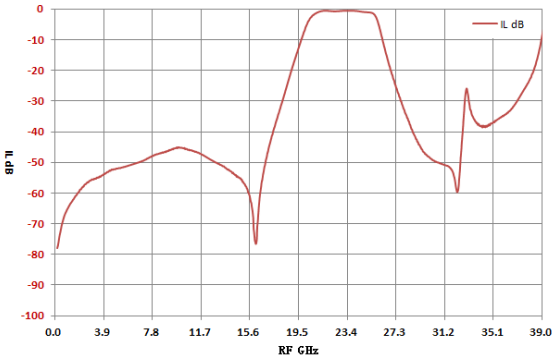
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



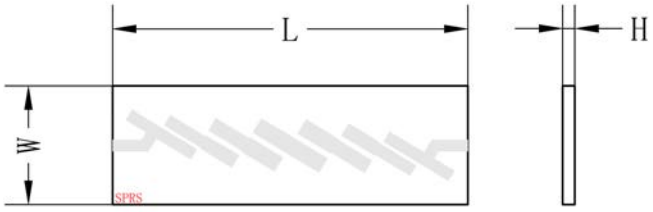
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	25.5	GHz
工作带宽	21.4-29.6	GHz
中心损耗	1.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-19.0GHz	dBc
带外抑制	40@34.3-42.0GHz	dBc

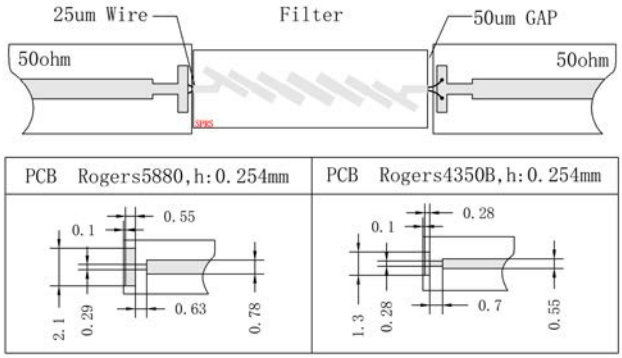
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：11.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



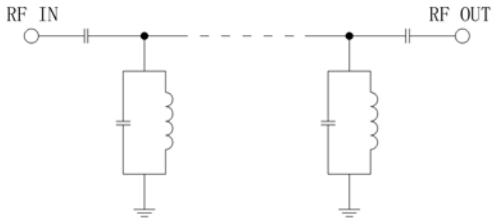
推荐装配图



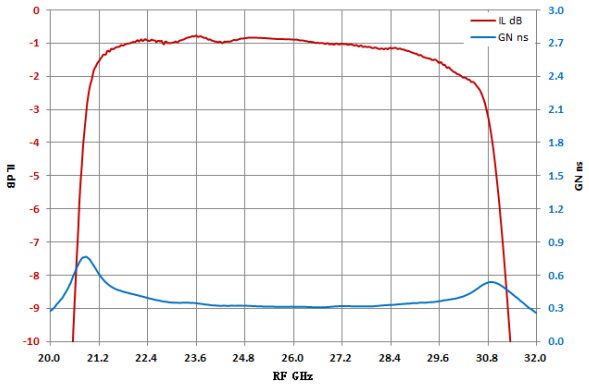
注意事项

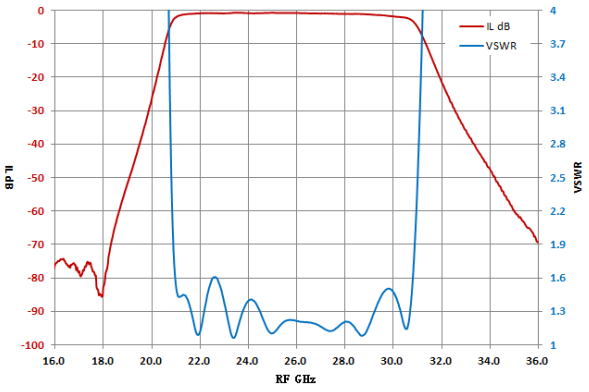
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

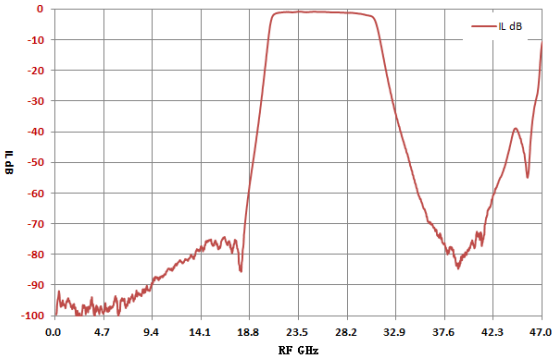
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

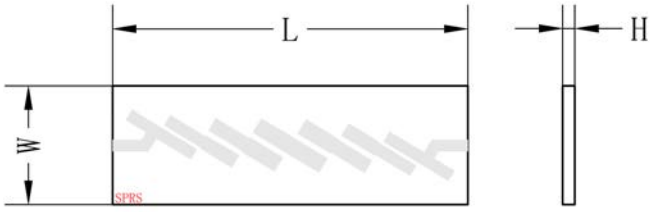
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	22.0	GHz
工作带宽	21.2-22.8	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-19.6GHz	dBc
带外抑制	40@24.2-26.0GHz	dBc

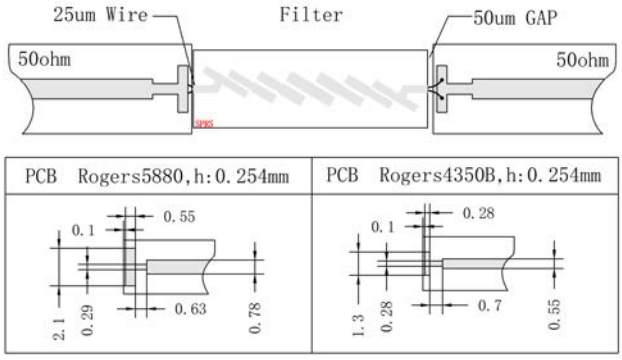
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



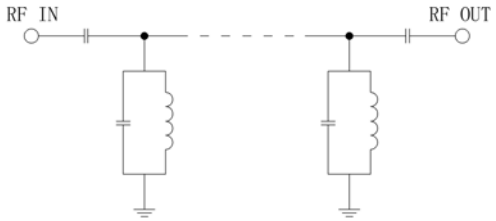
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

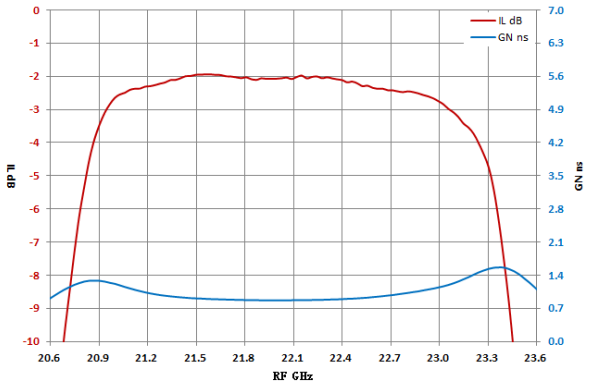
参考实物图

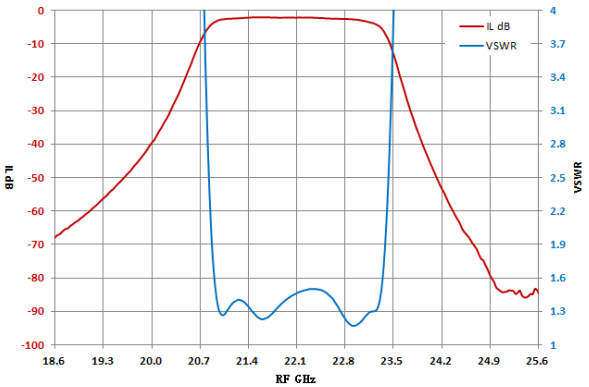


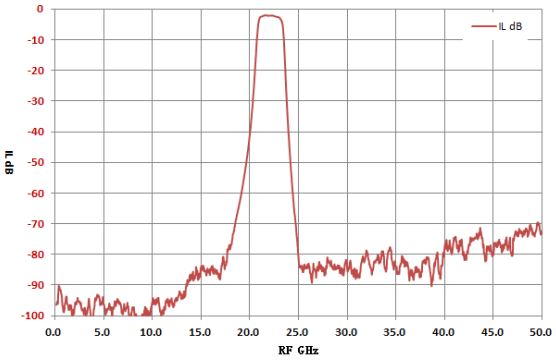
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



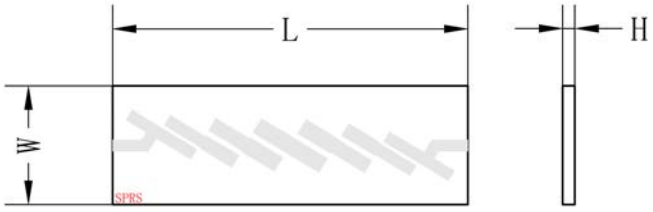
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	22.0	GHz
工作带宽	21.5-22.4	GHz
中心损耗	3.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-20.5GHz	dBc
带外抑制	40@23.5-30.0GHz	dBc

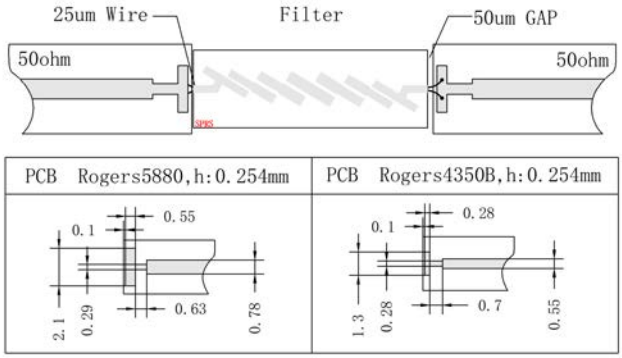
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



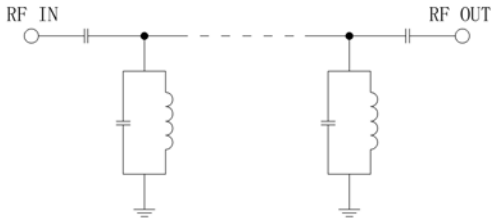
推荐装配图



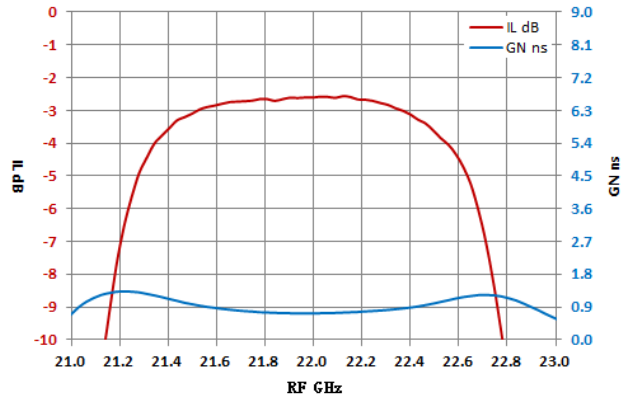
注意事项

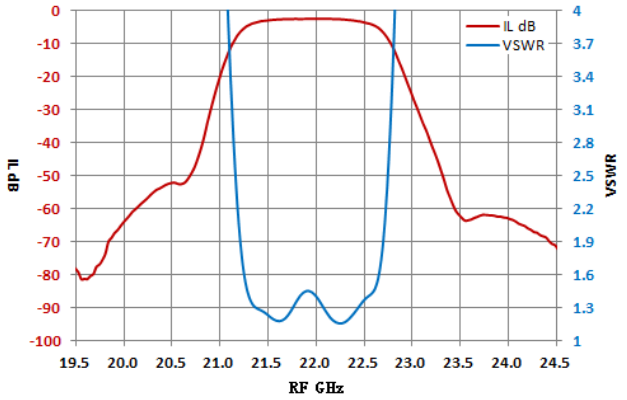
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

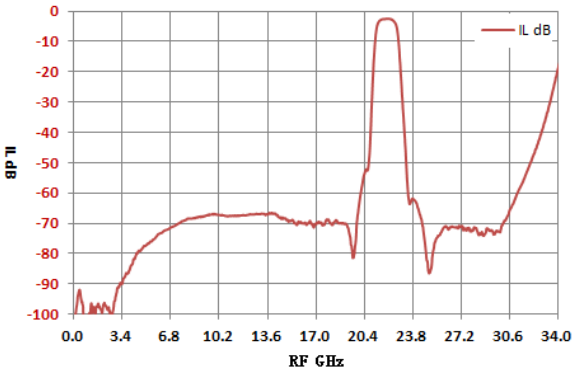
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

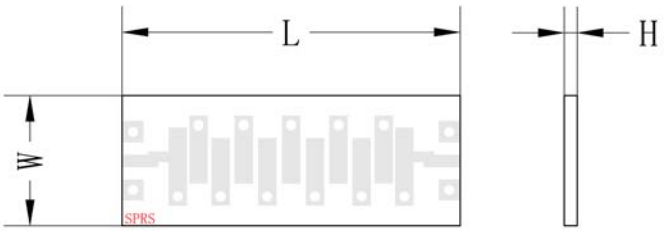
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	24.5	GHz
工作带宽	21.5-27.5	GHz
中心损耗	2.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	50@DC-18.8GHz	dBc
带外抑制	50@30.5-45.0GHz	dBc

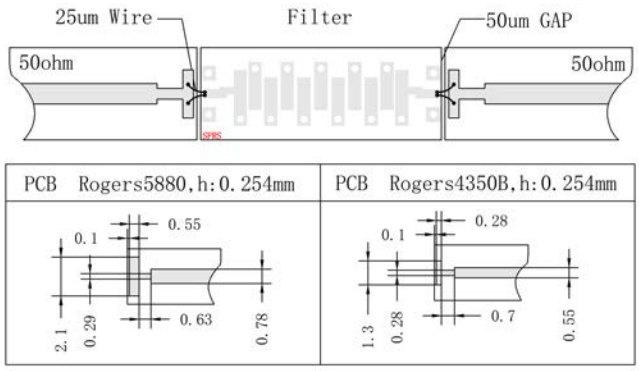
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

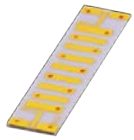
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

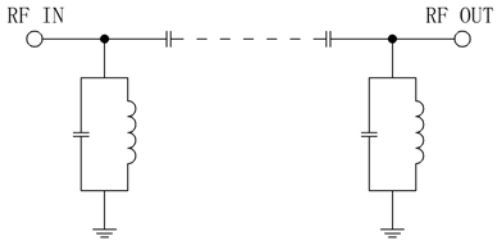
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

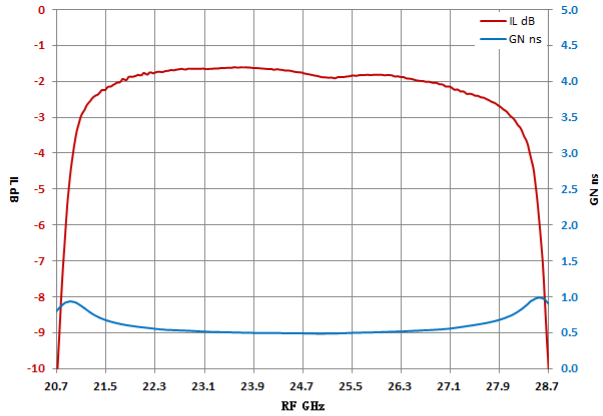
参考图

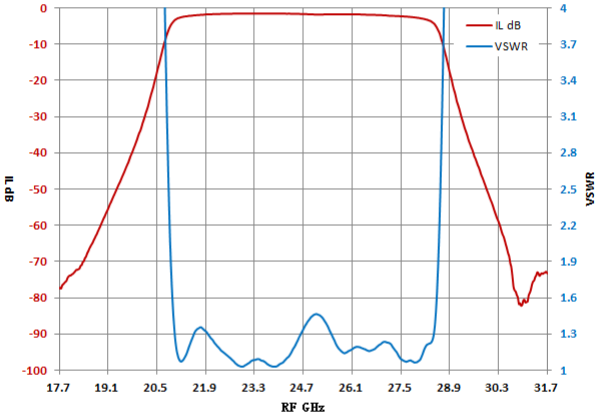


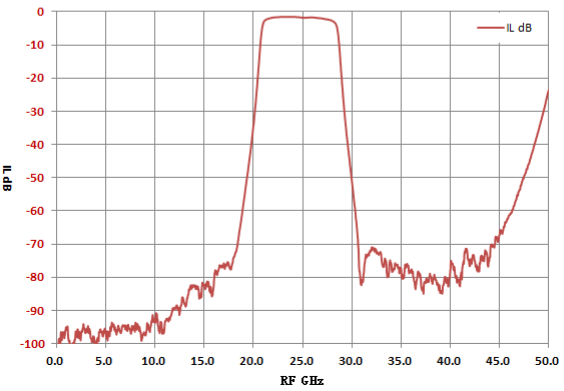
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

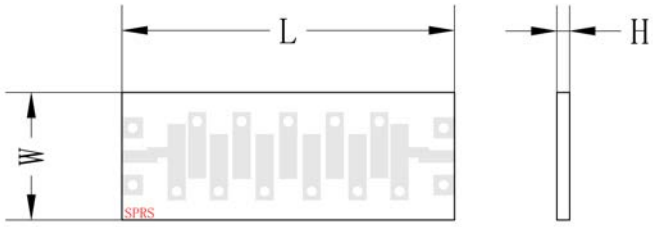
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	22.6	GHz
工作带宽	21.6-23.6	GHz
中心损耗	2.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-19.3GHz	dBc
带外抑制	40@26.4-46.0GHz	dBc

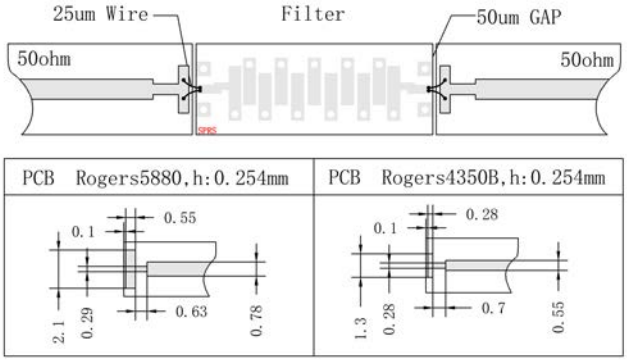
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



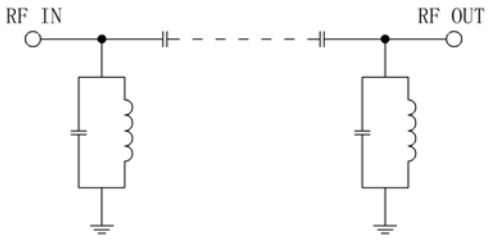
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

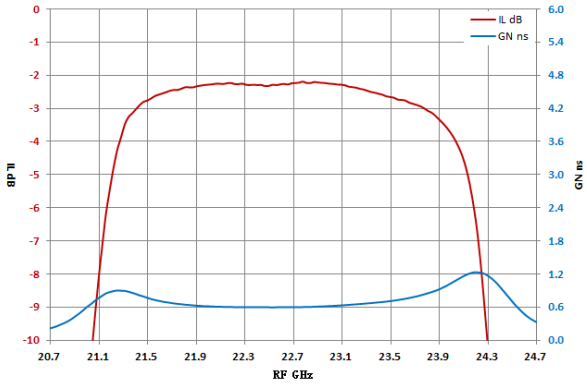
参考实物图

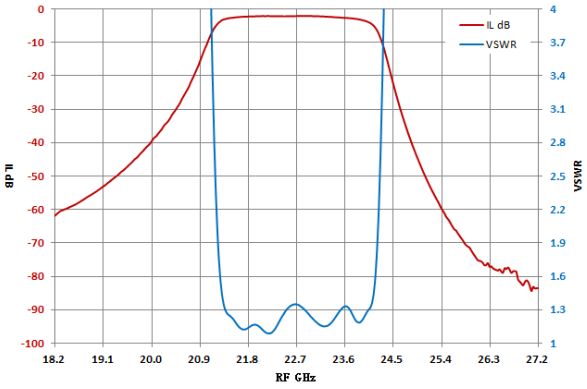


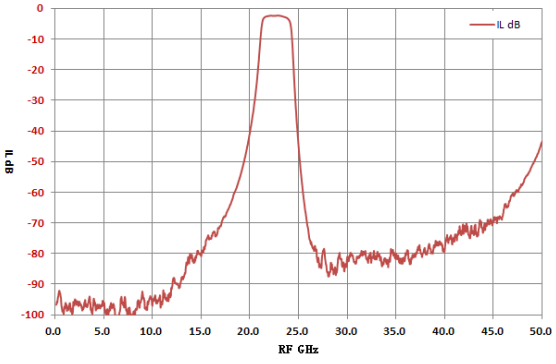
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

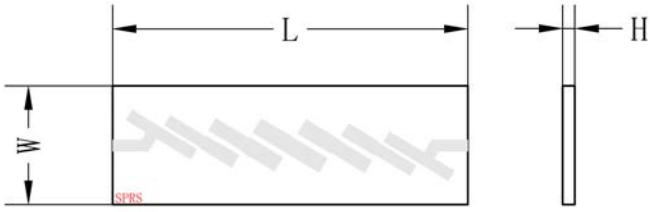
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	23.7	GHz
工作带宽	21.6-25.8	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-18.6GHz	dBc
带外抑制	40@29.2-36.0GHz	dBc

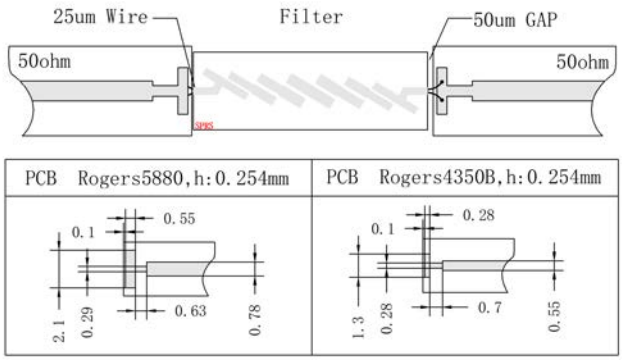
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



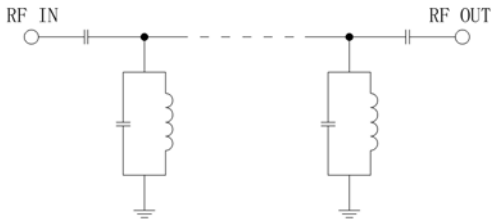
推荐装配图



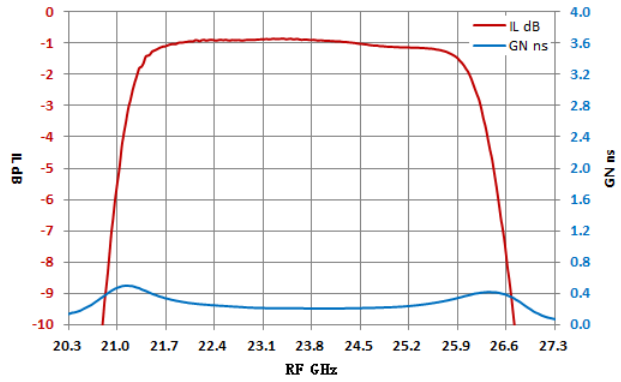
注意事项

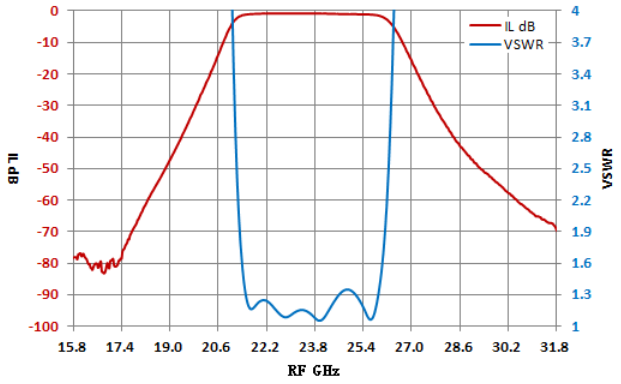
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.25mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

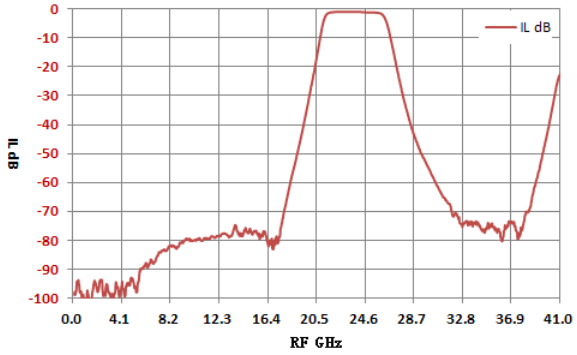
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

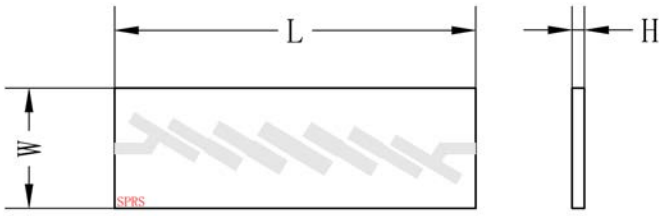
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	27.45	GHz
工作带宽	21.7-33.2	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-15.8GHz	dBc
带外抑制	40@42.0-60.0GHz	dBc

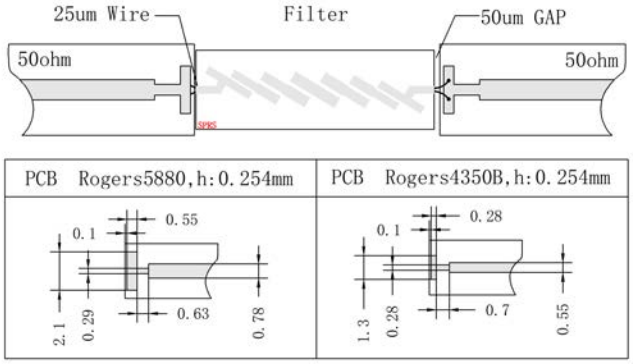
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：5.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

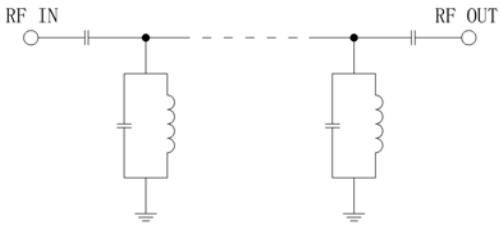
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

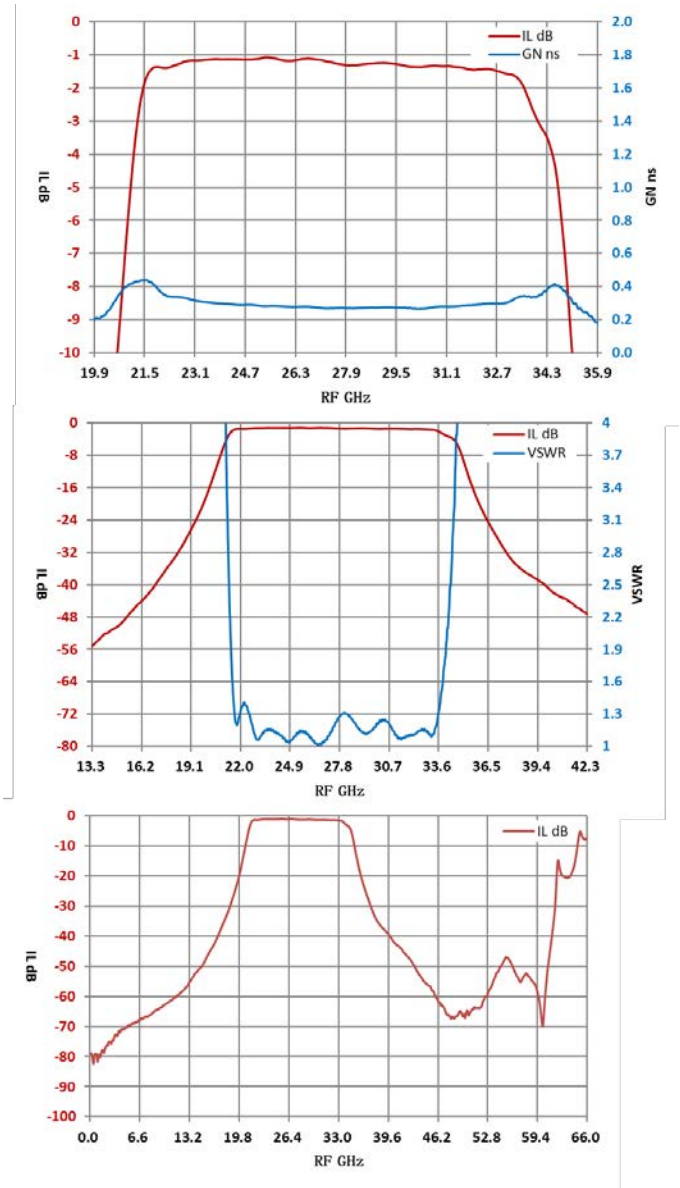
参考图



原理图



典型曲线



产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



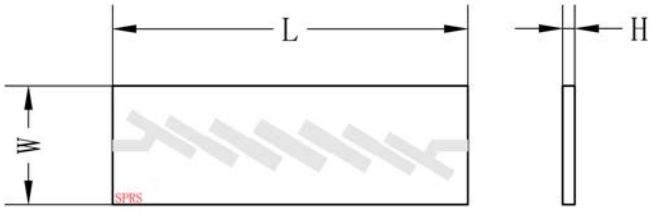
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	22.1	GHz
工作带宽	21.8-22.4	GHz
中心损耗	4.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-20.5GHz	dBc
带外抑制	40@23.7-31.0GHz	dBc

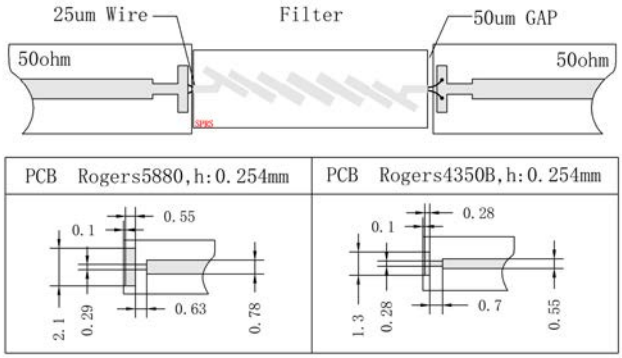
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：10.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



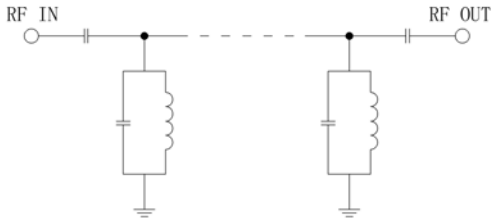
推荐装配图



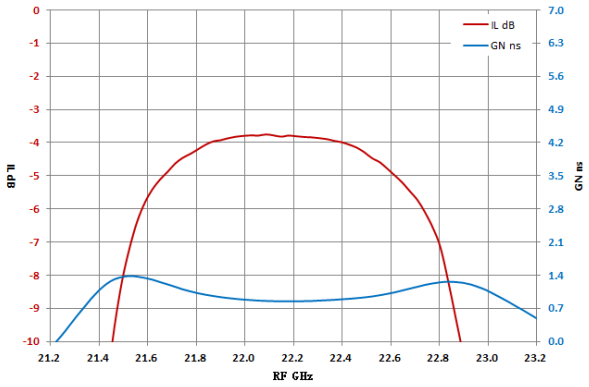
注意事项

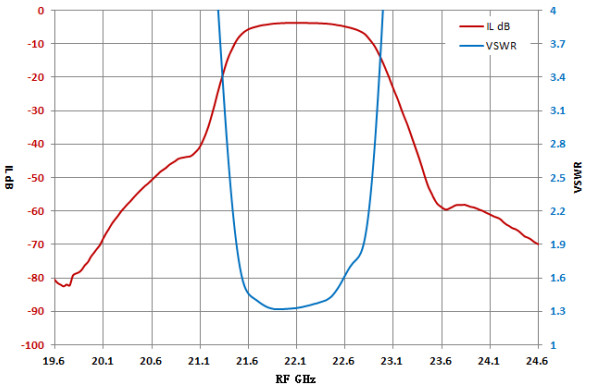
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

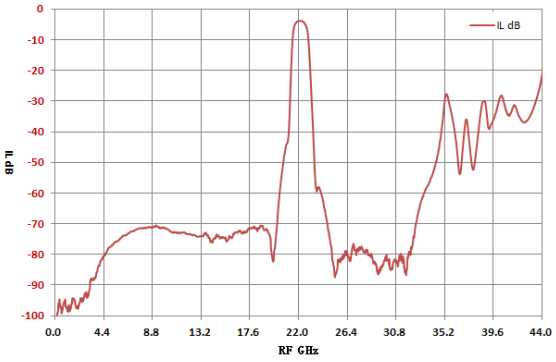
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



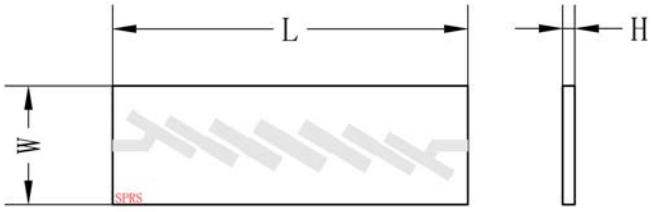
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	22.4	GHz
工作带宽	21.8-23.0	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	35@DC-20.5GHz	dBc
带外抑制	40@24.5-34.0GHz	dBc

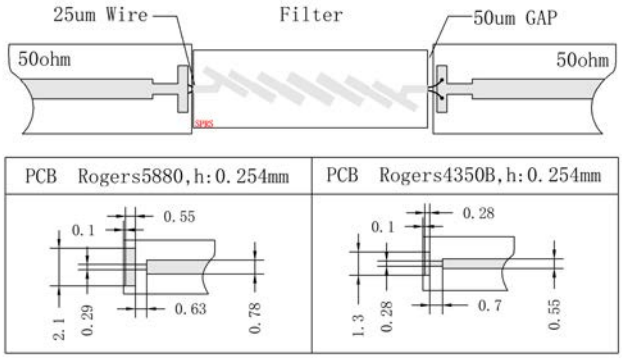
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



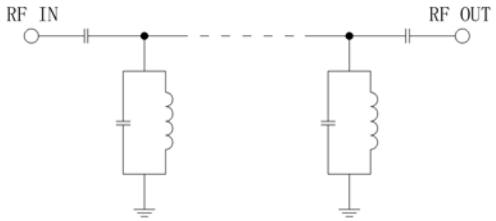
推荐装配图



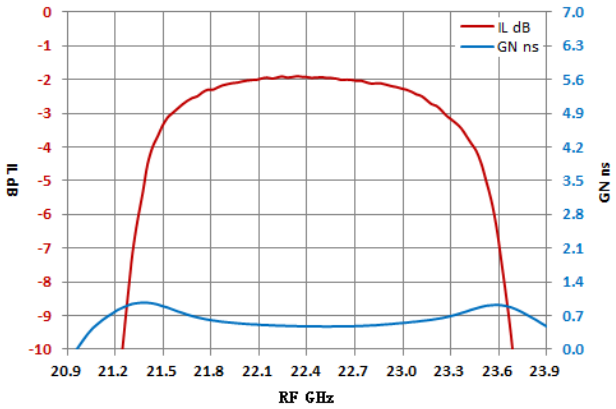
注意事项

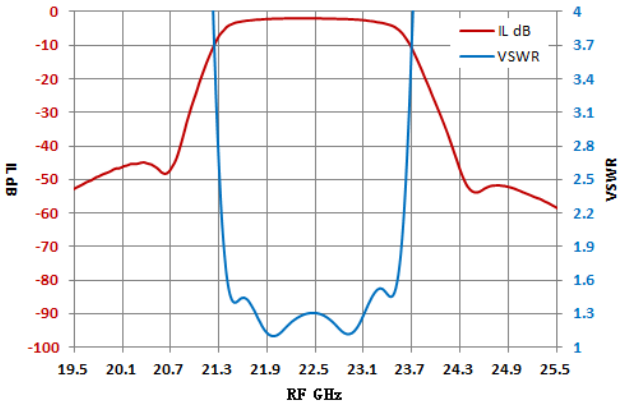
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

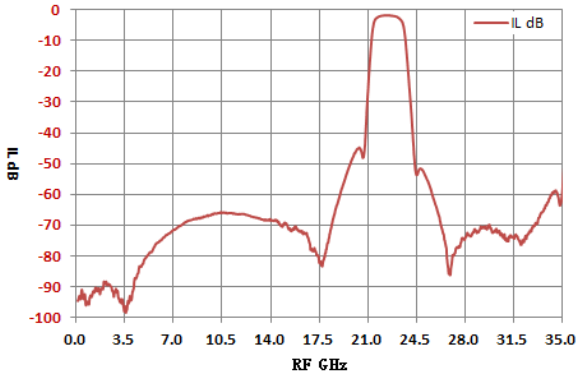
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

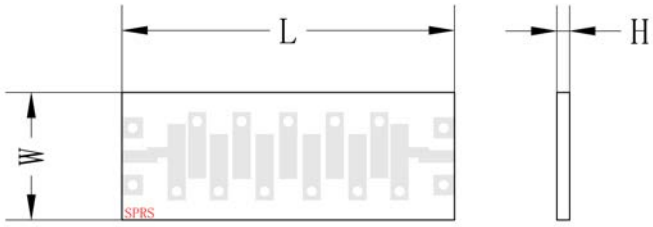
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	24.1	GHz
工作带宽	21.8-26.4	GHz
中心损耗	1.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-17.0GHz	dBc
带外抑制	40@30.1-45.0GHz	dBc

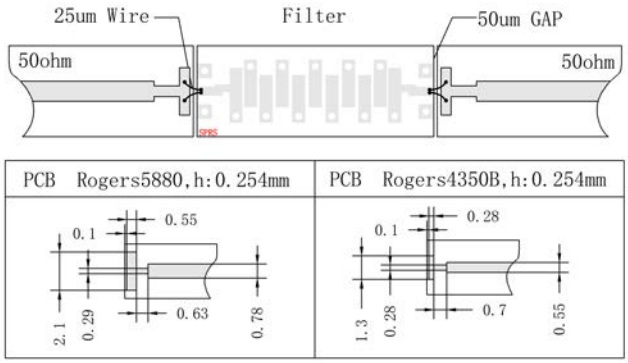
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5·，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



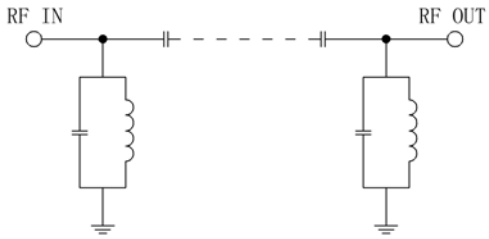
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

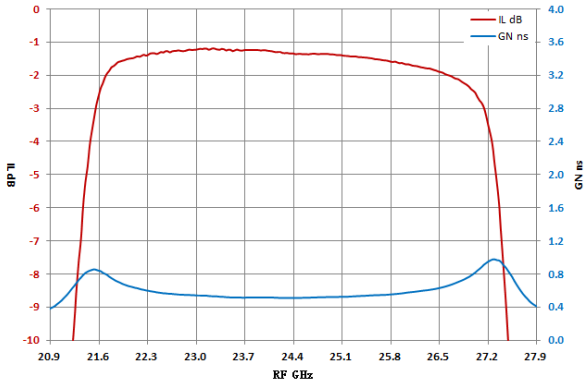
参考实物图

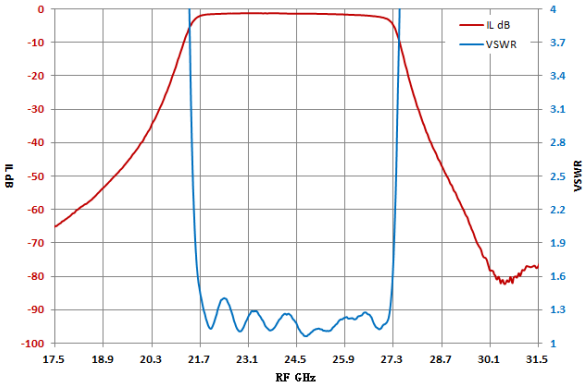


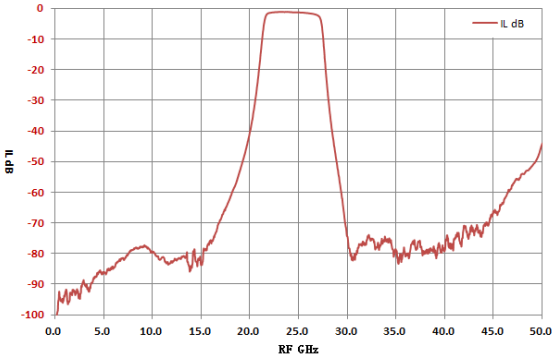
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



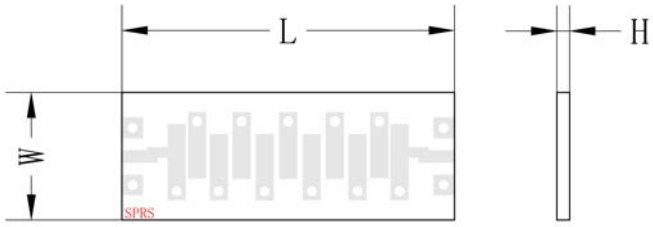
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	24.3	GHz
工作带宽	21.8-26.8	GHz
中心损耗	1.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-18.8GHz	dBc
带外抑制	40@28.8-45.0GHz	dBc

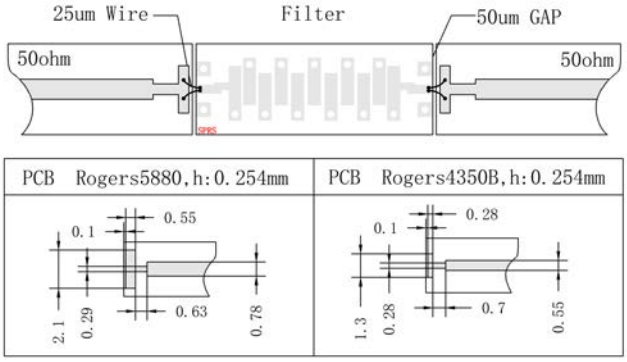
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



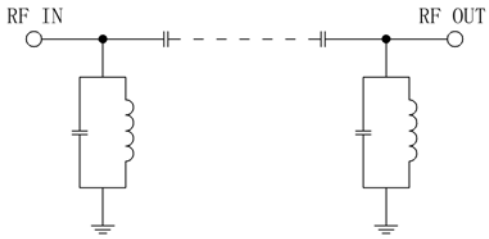
推荐装配图



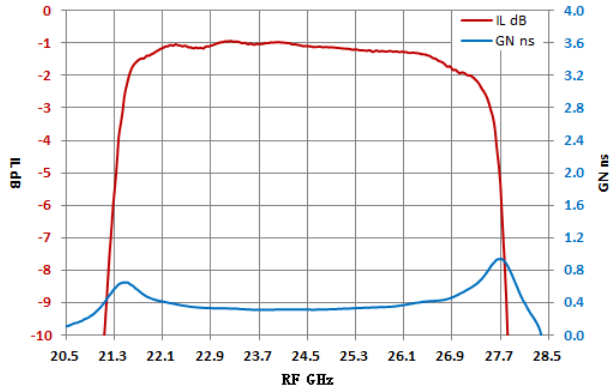
注意事项

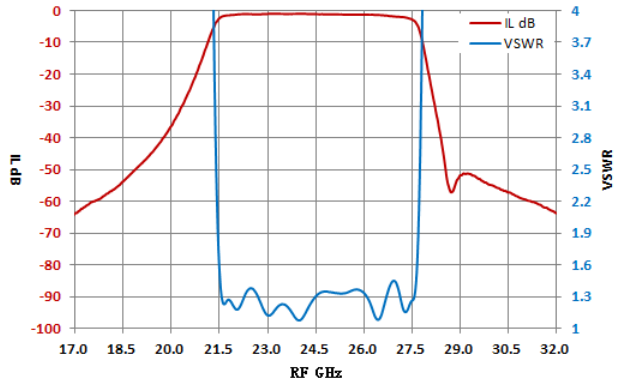
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

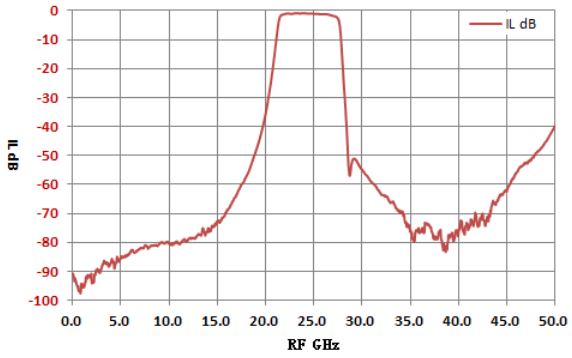
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

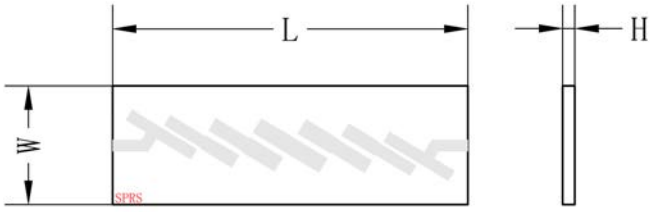
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	25.0	GHz
工作带宽	21.8-28.2	GHz
中心损耗	1.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-17.4GHz	dBc
带外抑制	40@33.4-39.0GHz	dBc

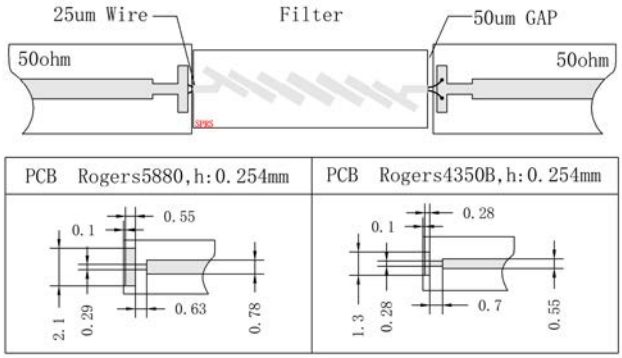
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



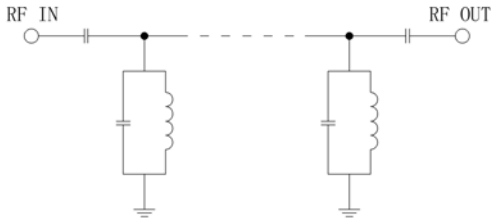
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

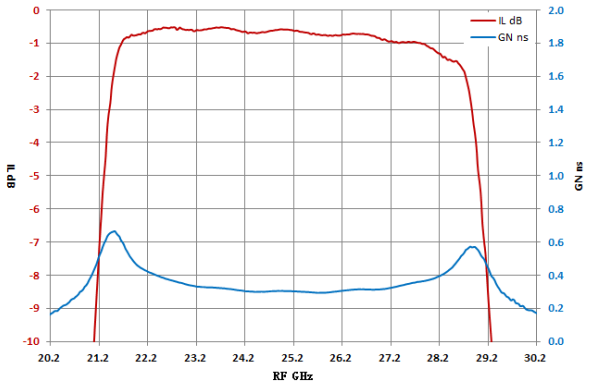
参考实物图

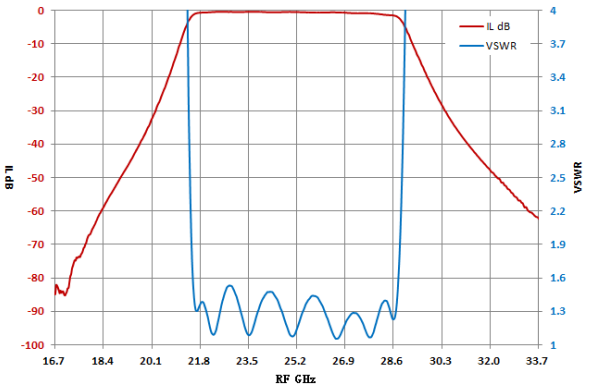


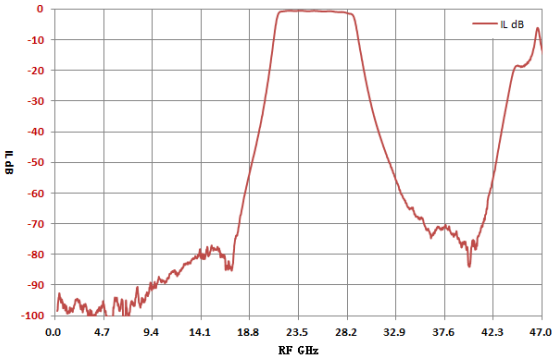
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

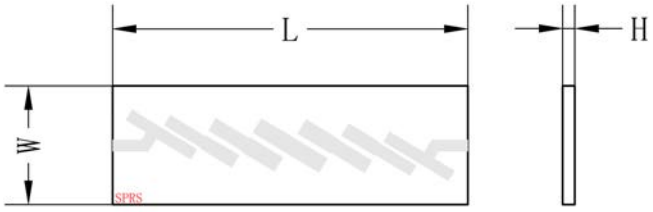
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	22.3	GHz
工作带宽	21.9-22.7	GHz
中心损耗	2.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-21.1GHz	dBc
带外抑制	40@23.9-33.0GHz	dBc

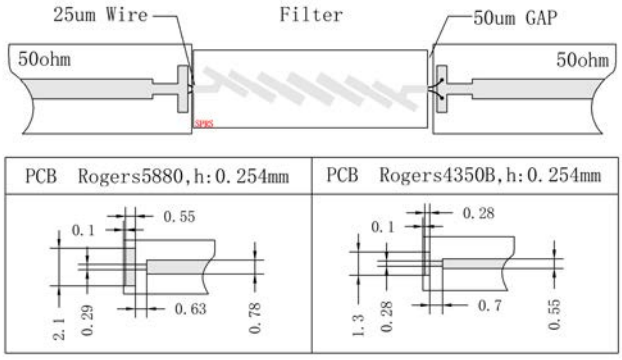
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.9，W：3.75，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



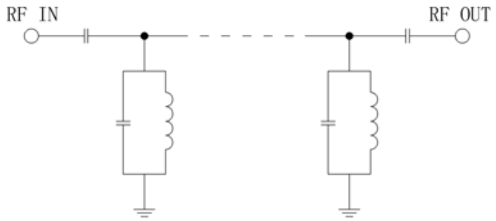
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.7mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

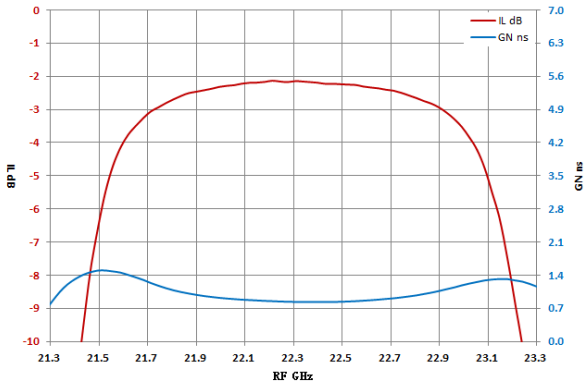
参考实物图

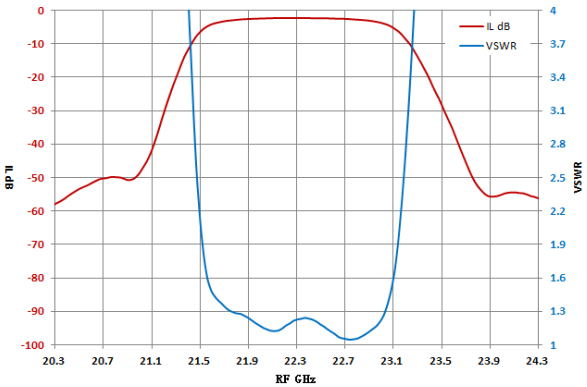


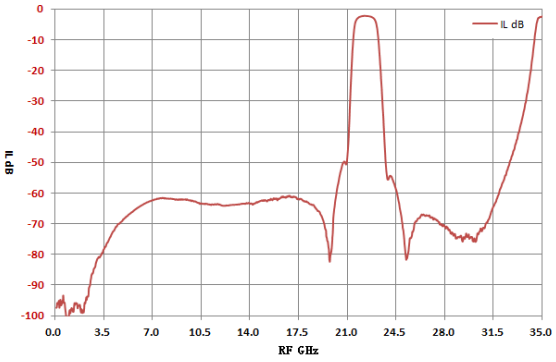
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

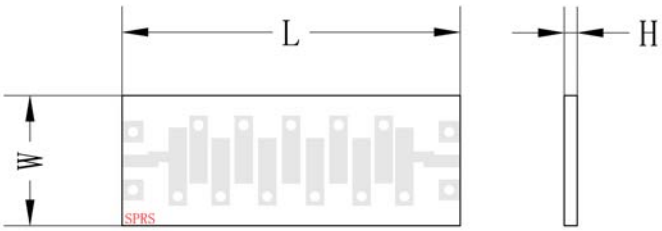
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	22.65	GHz
工作带宽	21.9-23.4	GHz
中心损耗	3.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	50@DC-20.4GHz	dBc
带外抑制	45@24.7-50.5GHz	dBc

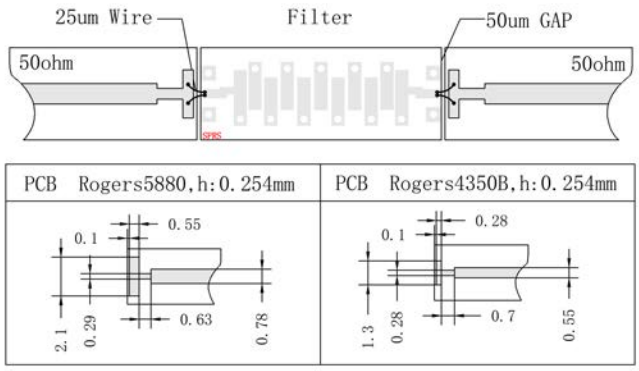
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

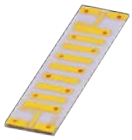
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

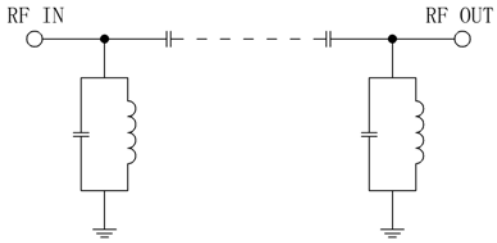
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

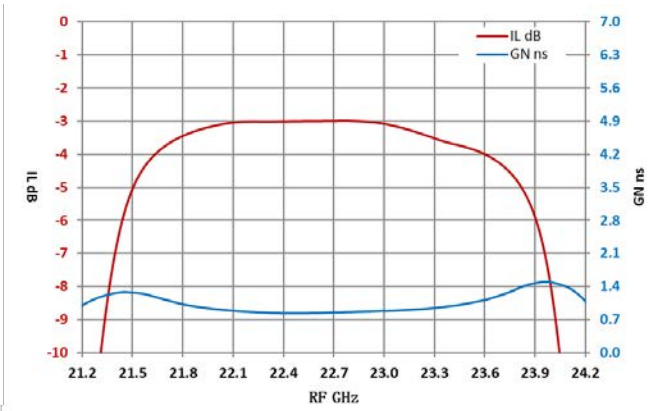
参考图

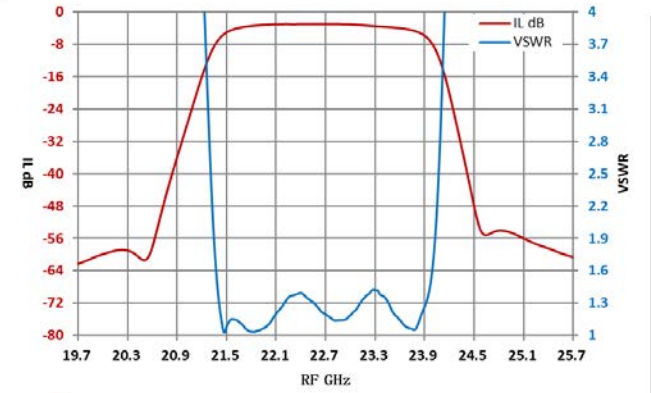


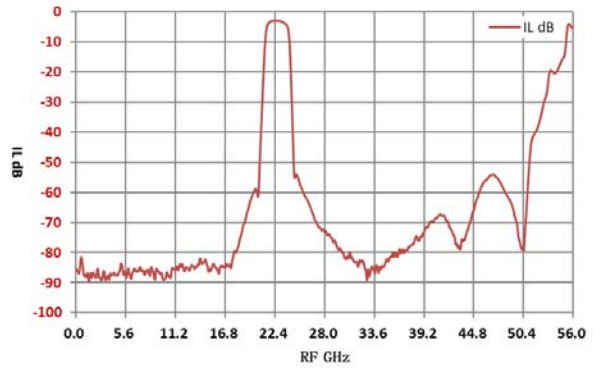
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

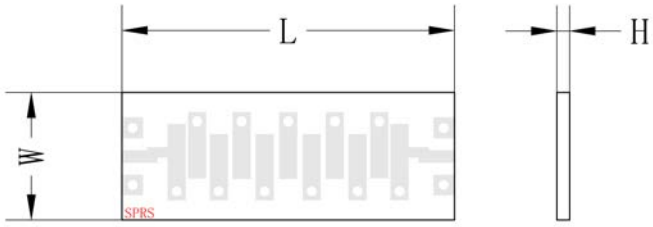
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	23.5	GHz
工作带宽	22.0-25.0	GHz
中心损耗	2.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-20.3GHz	dBc
带外抑制	40@27.6-44.0GHz	dBc

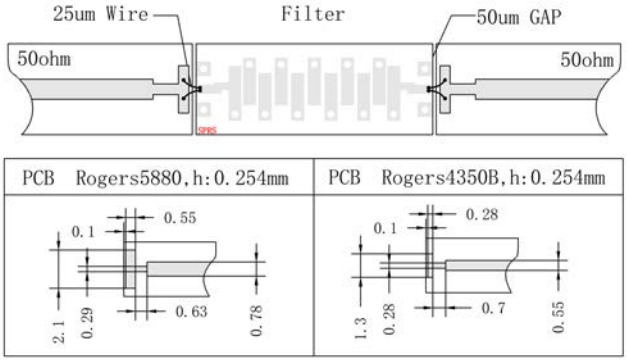
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



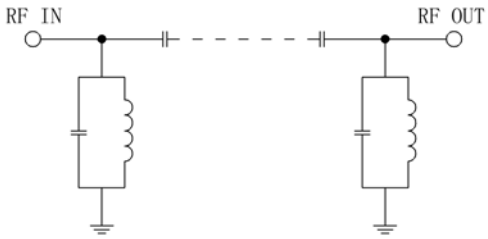
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

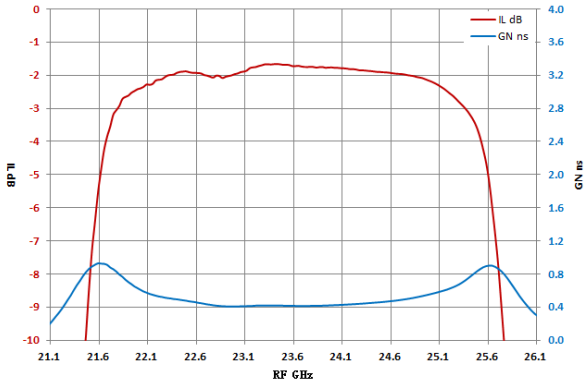
参考实物图

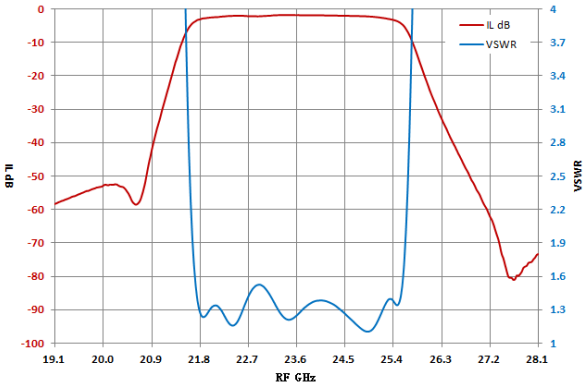


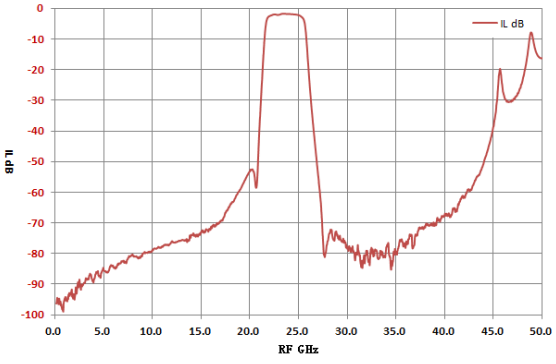
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



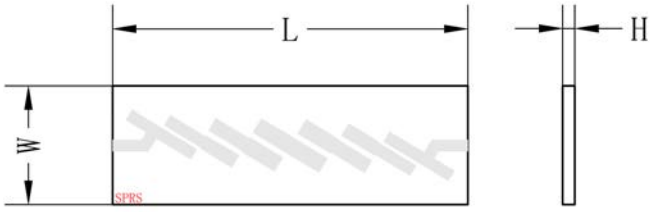
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	23.6	GHz
工作带宽	22.0-25.2	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-20.5GHz	dBc
带外抑制	40@27.0-33.0GHz	dBc

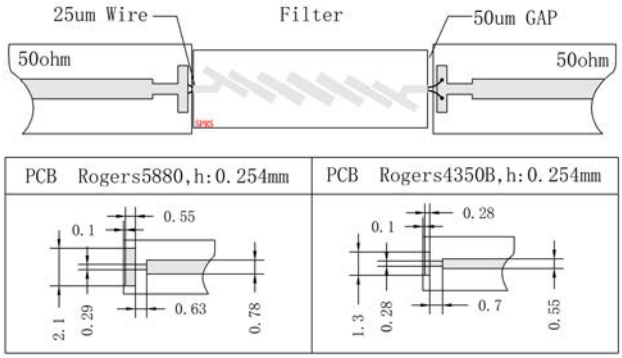
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



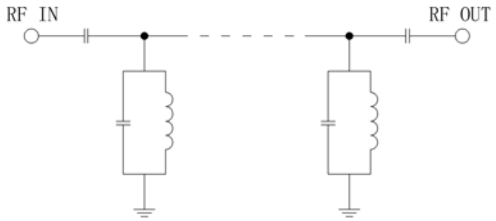
推荐装配图



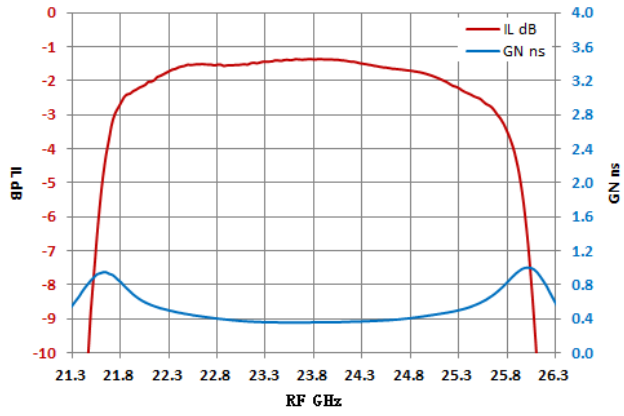
注意事项

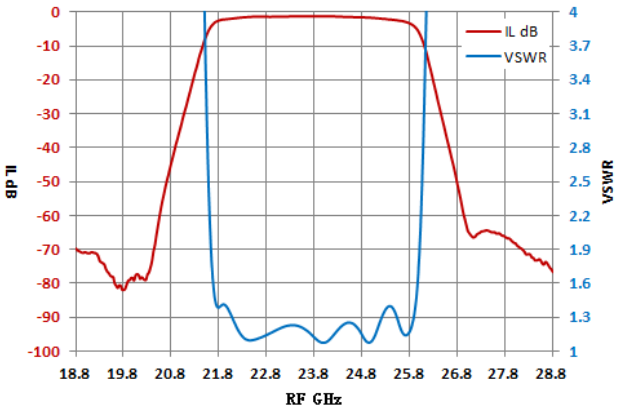
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

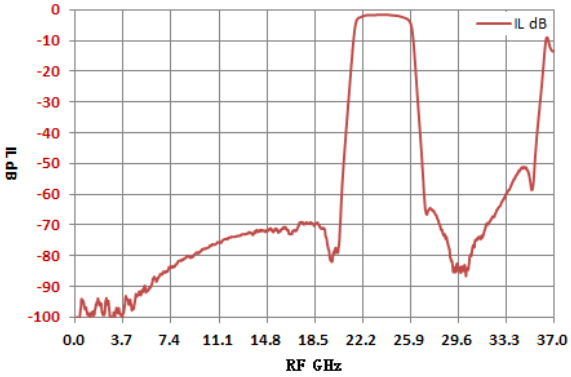
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

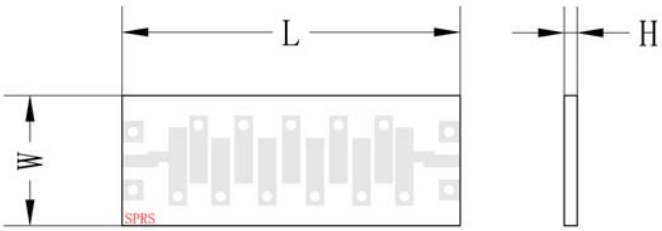
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	26.4	GHz
工作带宽	22.0-30.8	GHz
中心损耗	2.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-18.6GHz	dBc
带外抑制	40@33.6-58.0GHz	dBc

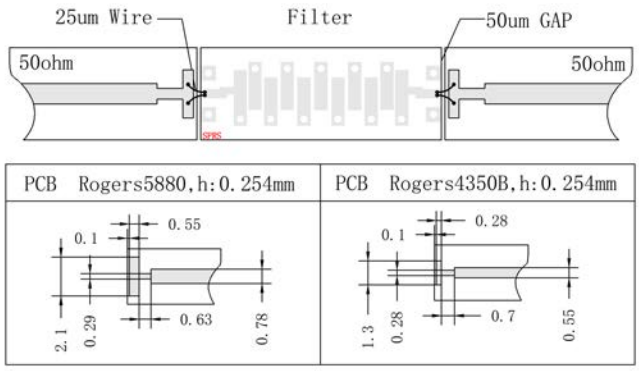
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：7.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

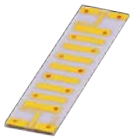
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

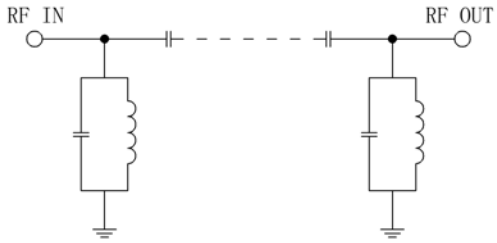
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

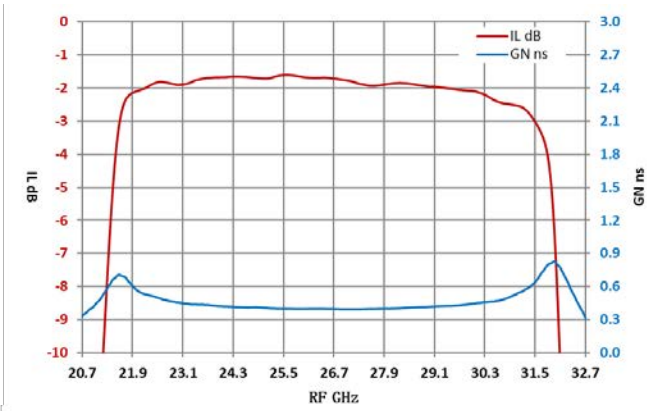
参考图

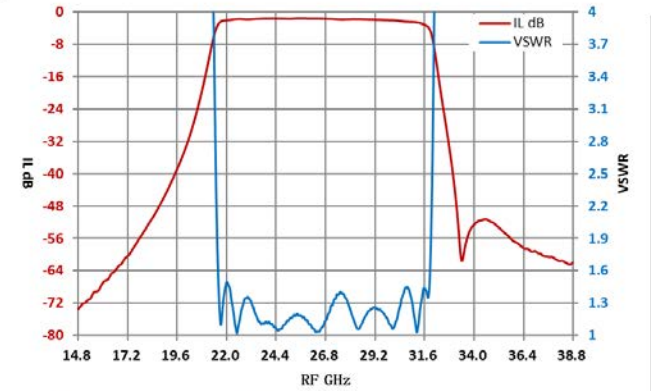


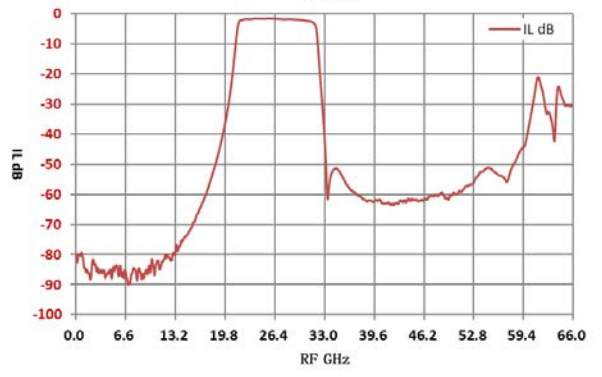
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



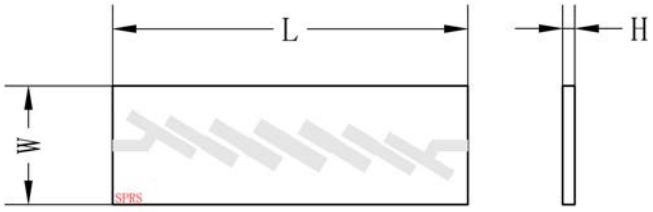
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	22.5	GHz
工作带宽	22.1-22.8	GHz
中心损耗	4.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-21.1GHz	dBc
带外抑制	40@23.6-29.0GHz	dBc

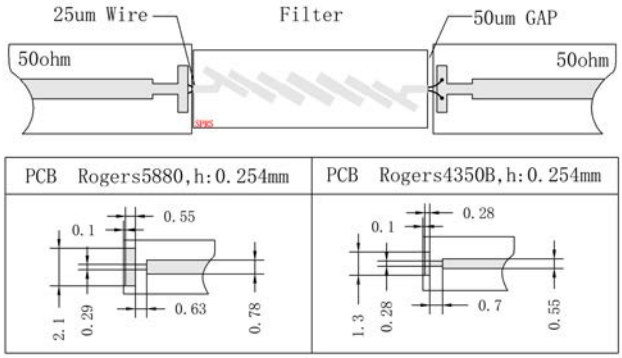
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



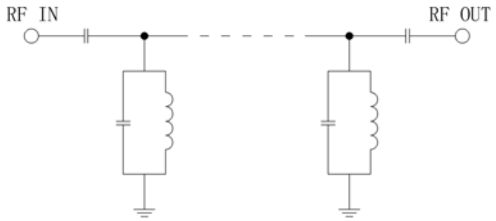
推荐装配图



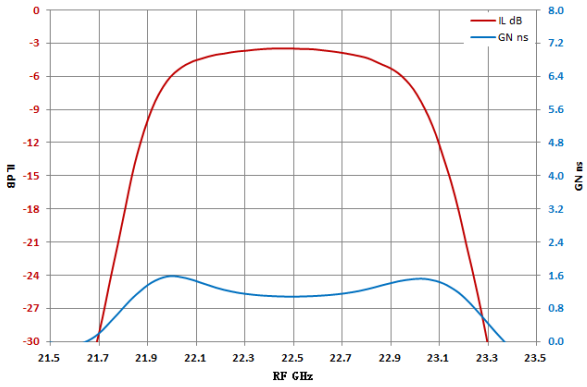
注意事项

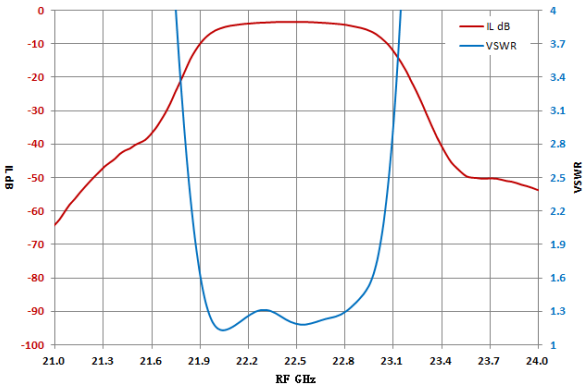
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

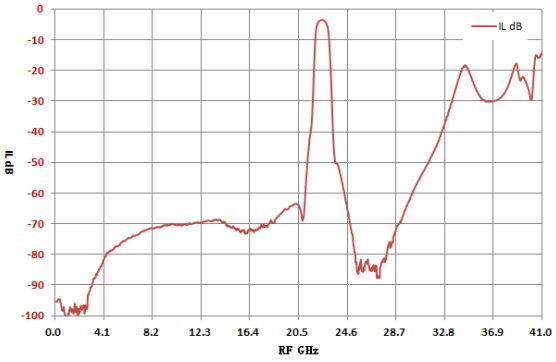
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



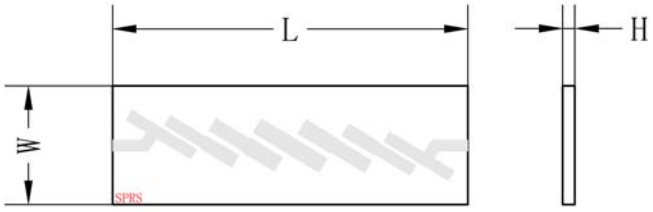
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	22.5	GHz
工作带宽	22.2-22.8	GHz
中心损耗	3.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	20@DC-21.3GHz	dBc
带外抑制	25@23.7-35.0GHz	dBc

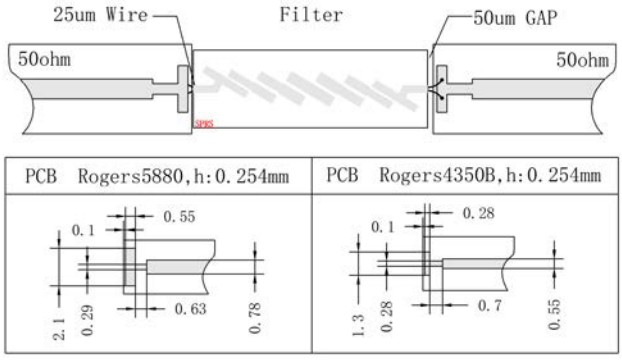
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：4.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



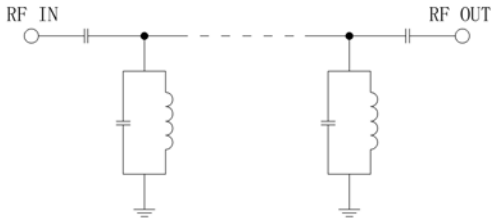
推荐装配图



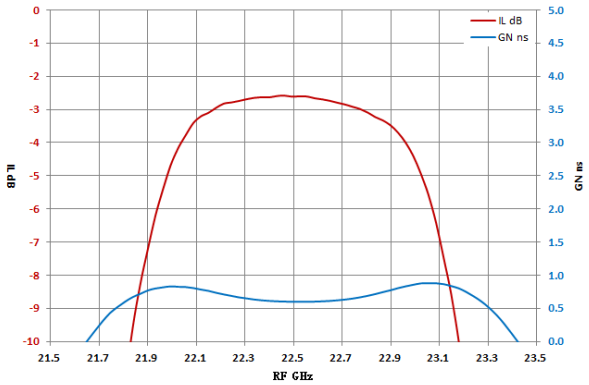
注意事项

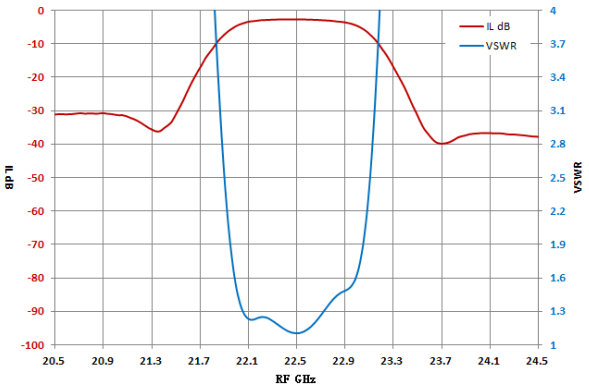
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

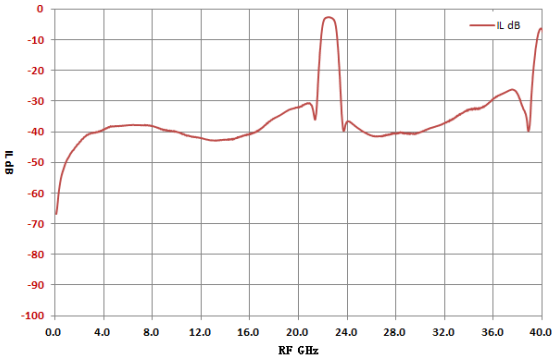
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

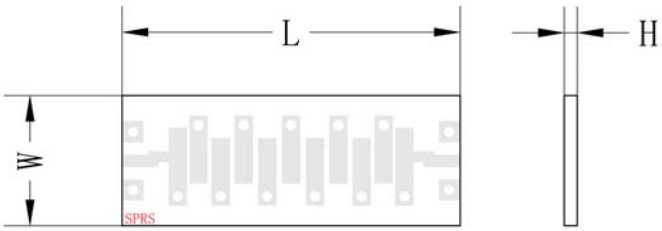
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	22.6	GHz
工作带宽	22.2-23.0	GHz
中心损耗	5.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	50@DC-21.0GHz	dBc
带外抑制	50@24.0-49.0GHz	dBc

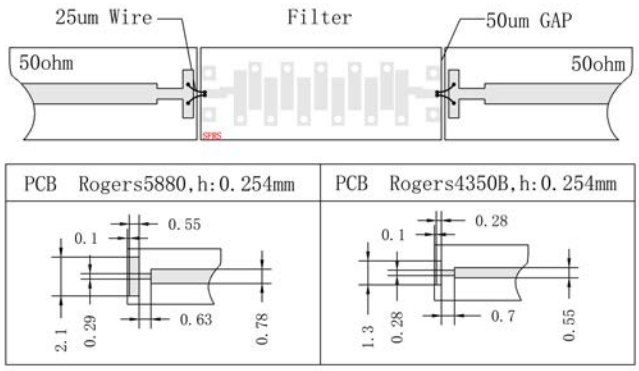
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

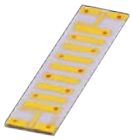
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

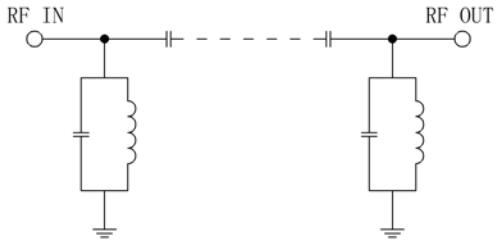
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

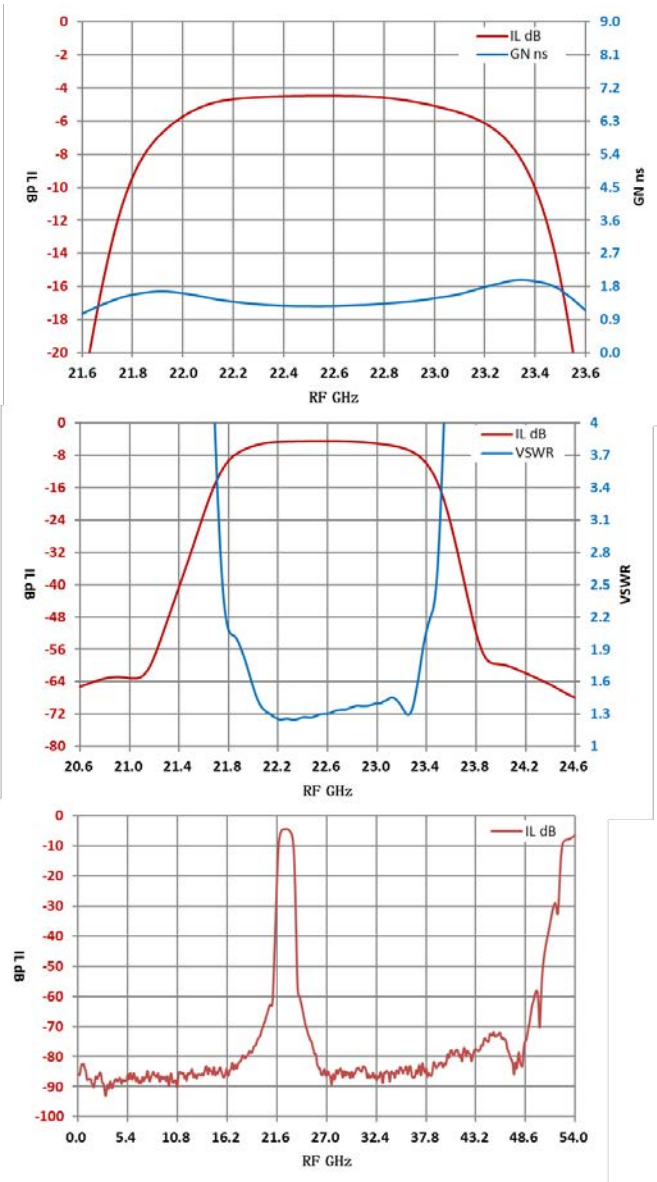
参考图



原理图



典型曲线



陶瓷滤波器 STBP228-1R2-M460

工作带宽 22.2-23.4GHz,带外抑制 35@DC-20.9GHz,35@24.8-40.0GHz

产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



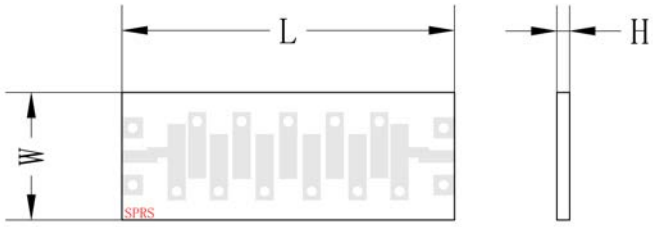
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	22.8	GHz
工作带宽	22.2-23.4	GHz
中心损耗	2.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	35@DC-20.9GHz	dBc
带外抑制	35@24.8-40.0GHz	dBc

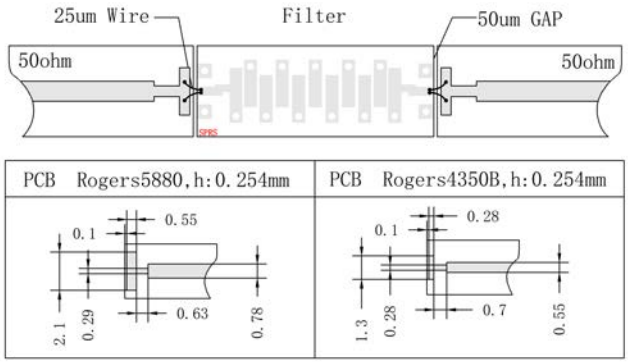
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



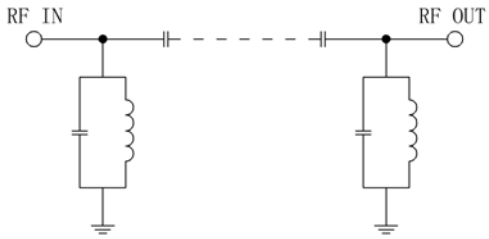
推荐装配图



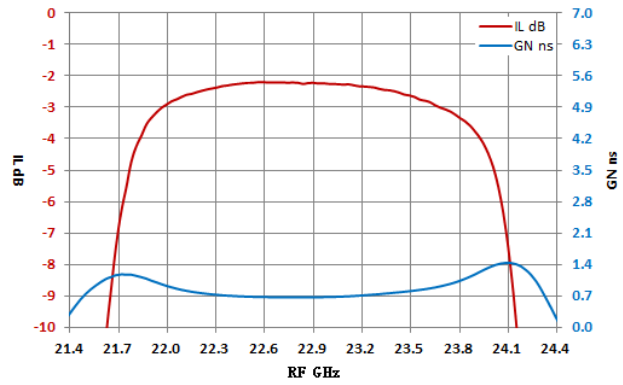
注意事项

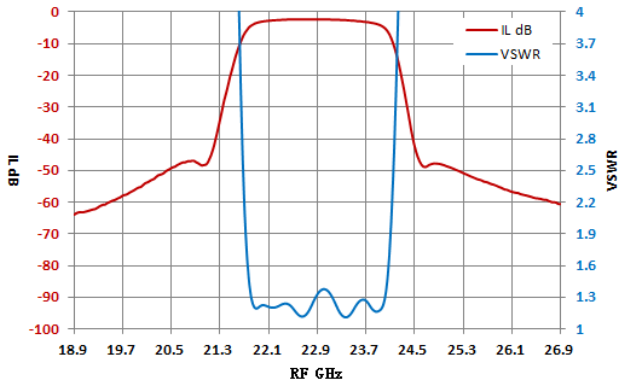
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

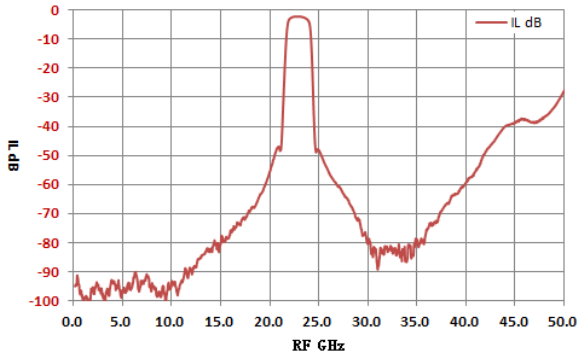
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

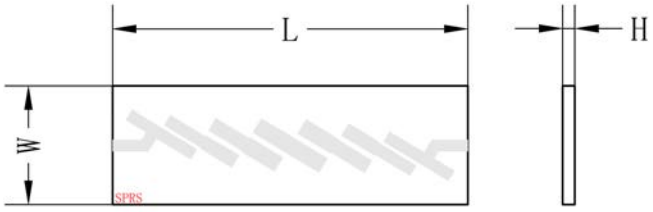
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	22.9	GHz
工作带宽	22.2-23.6	GHz
中心损耗	2.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-20.8GHz	dBc
带外抑制	40@25.2-35.0GHz	dBc

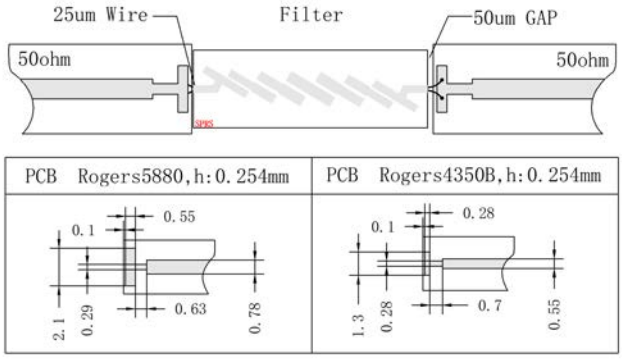
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



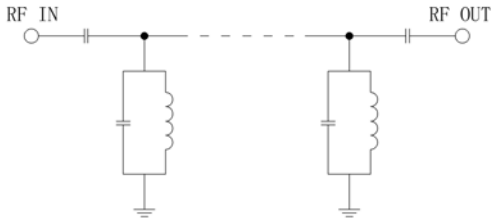
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

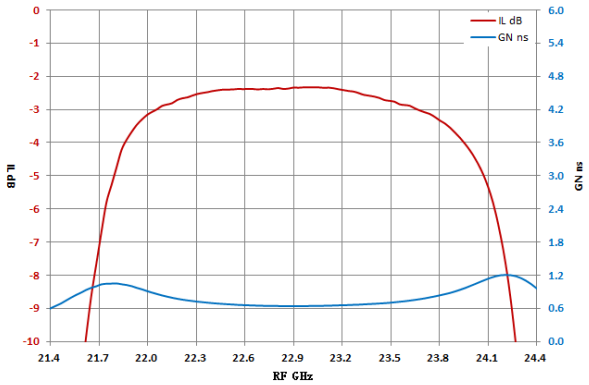
参考实物图

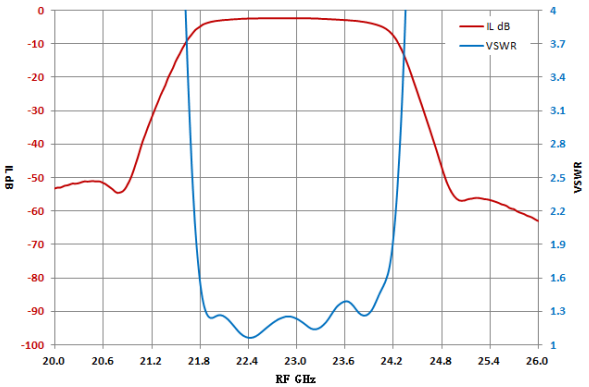


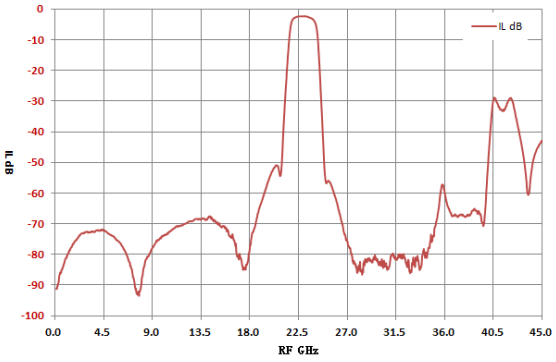
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

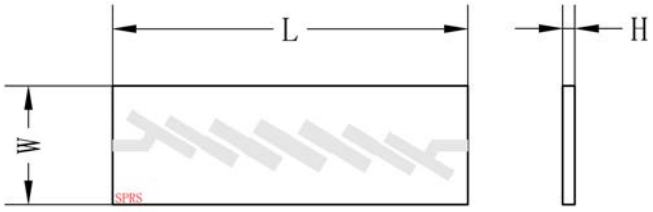
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	23.7	GHz
工作带宽	22.2-25.2	GHz
中心损耗	1.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-20.5GHz	dBc
带外抑制	40@27.0-35.0GHz	dBc

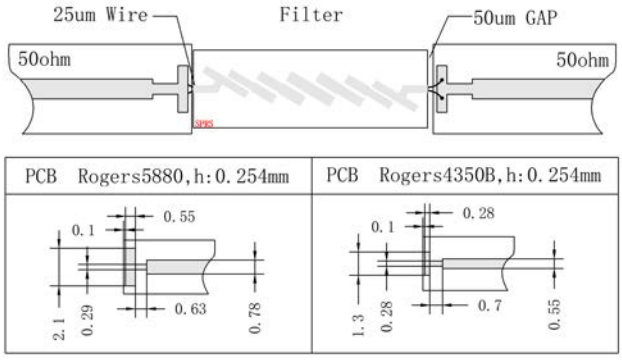
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



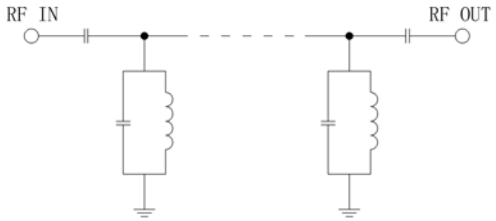
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

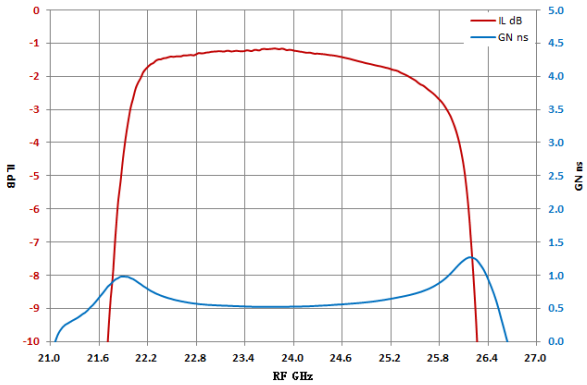
参考实物图

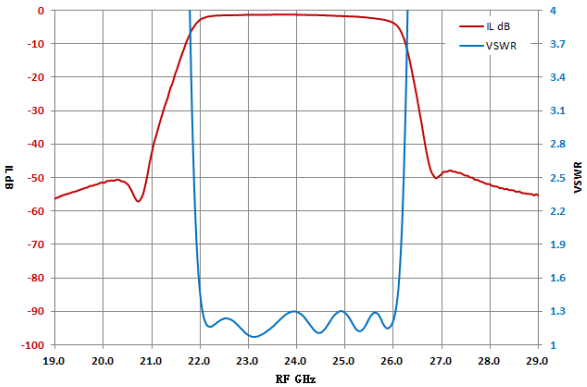


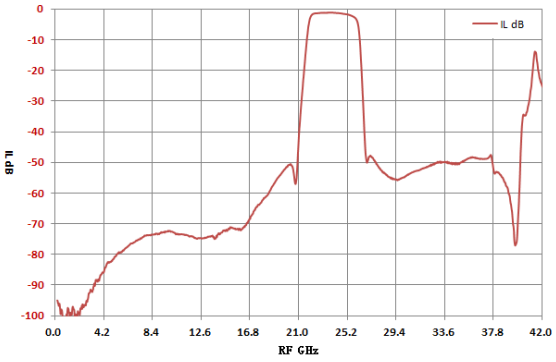
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



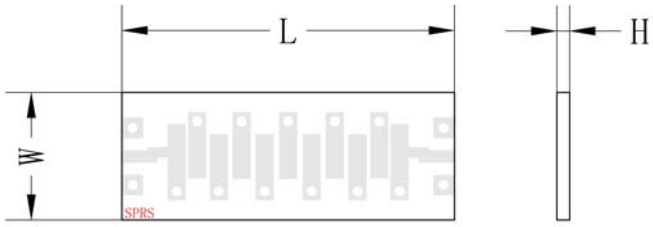
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	24.2	GHz
工作带宽	22.2-26.2	GHz
中心损耗	1.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-19.5GHz	dBc
带外抑制	40@28.3-45.0GHz	dBc

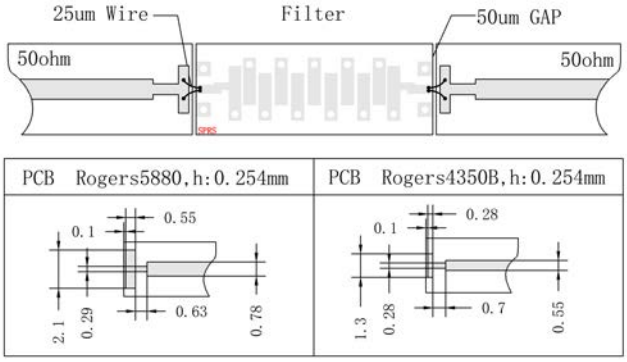
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



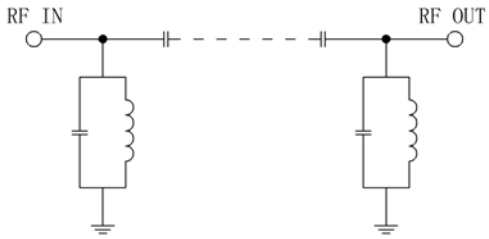
推荐装配图



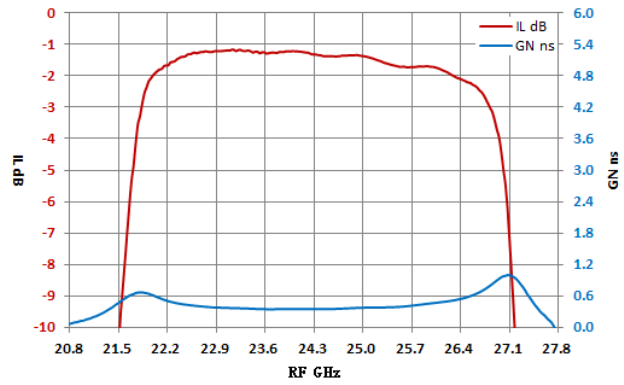
注意事项

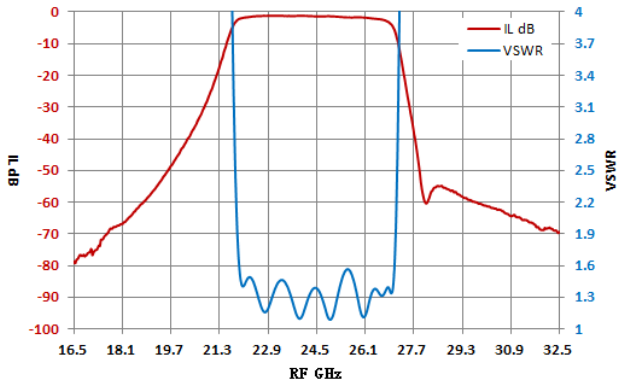
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

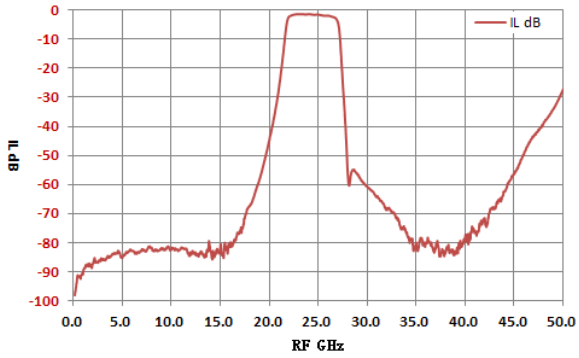
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

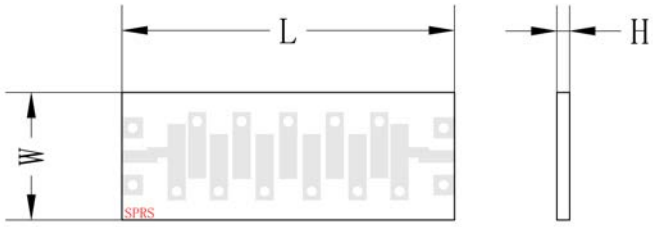
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	24.8	GHz
工作带宽	22.2-27.4	GHz
中心损耗	2.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-18.9GHz	dBc
带外抑制	40@30.5-45.0GHz	dBc

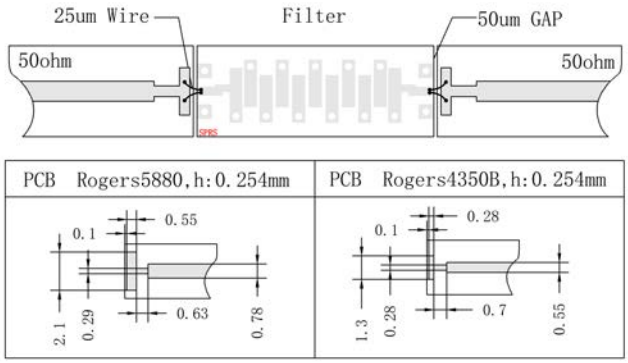
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.4，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



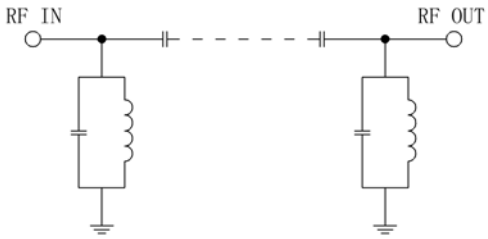
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

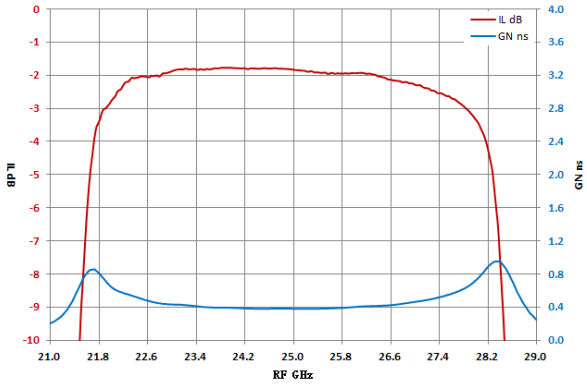
参考实物图

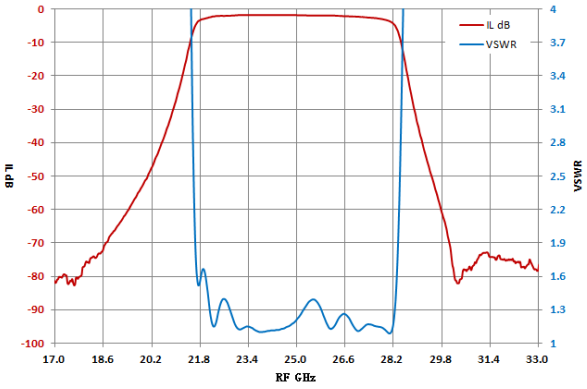


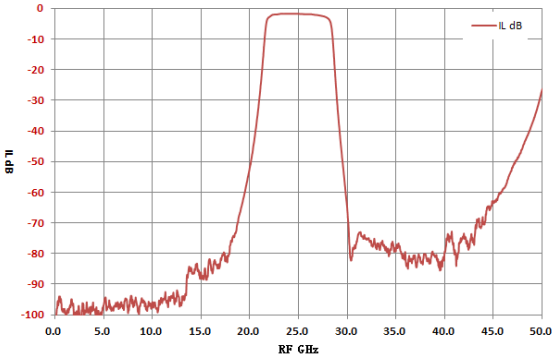
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

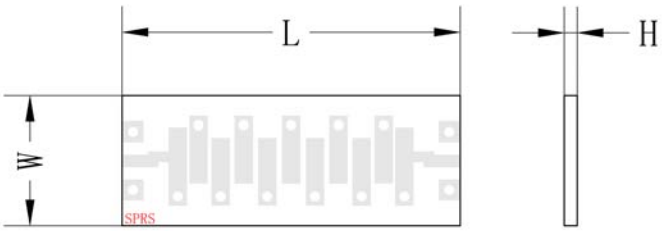
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	26.1	GHz
工作带宽	22.2-30.0	GHz
中心损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	55@DC-19.8GHz	dBc
带外抑制	50@32.2-56.0GHz	dBc

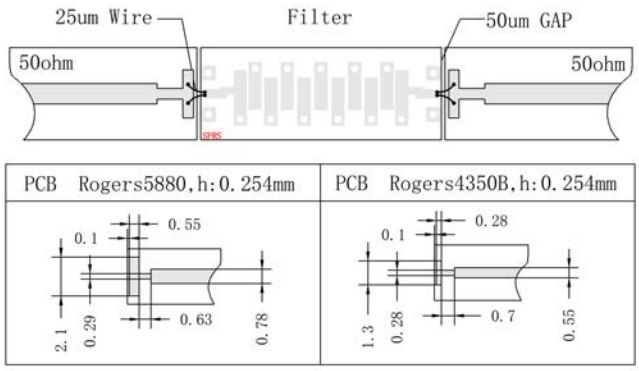
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：6.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

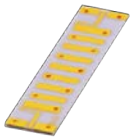
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

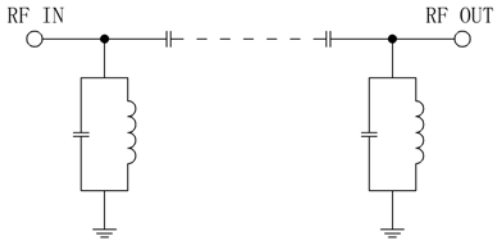
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

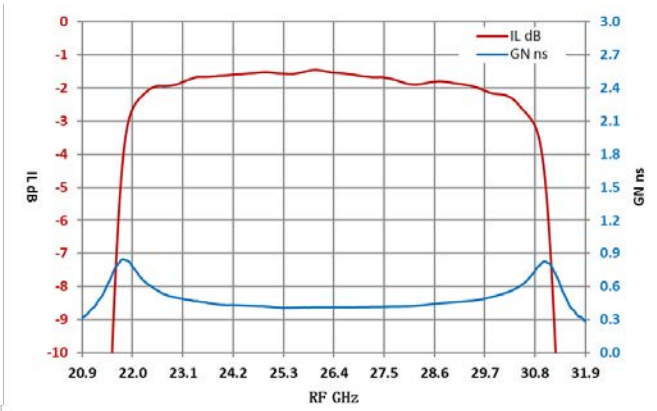
参考图

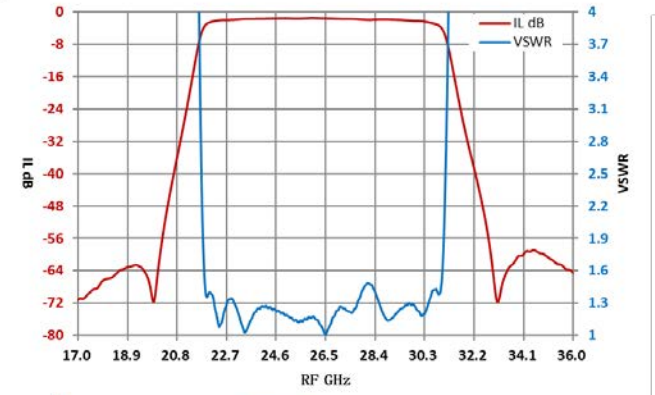


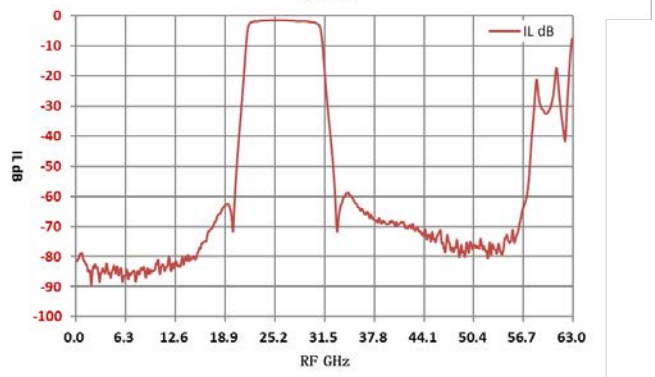
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

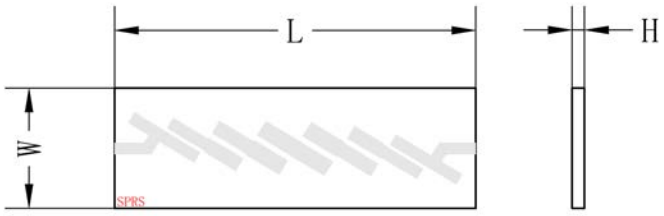
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	22.4	GHz
工作带宽	22.3-22.5	GHz
中心损耗	3.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	35@DC-21.0GHz	dBc
带外抑制	30@23.4-32.0GHz	dBc

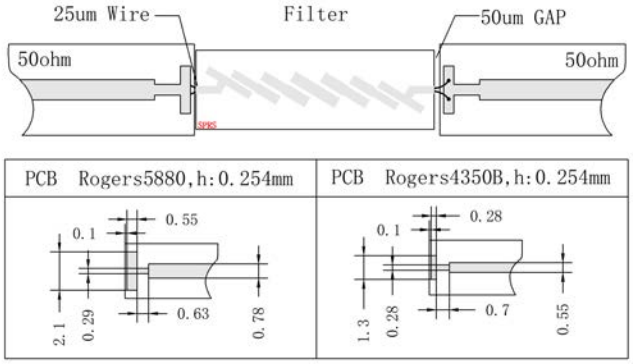
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：4.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

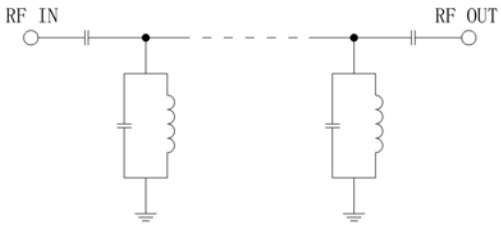
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

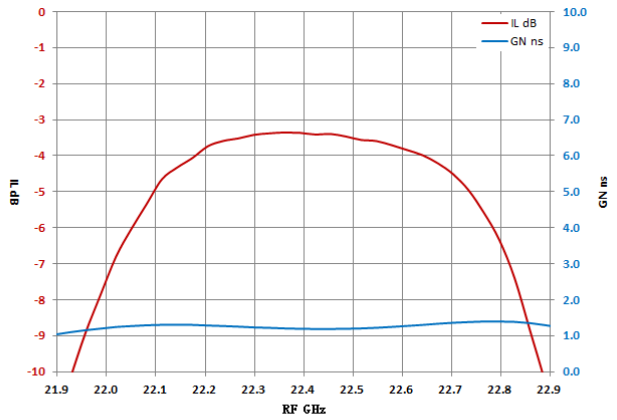
参考图

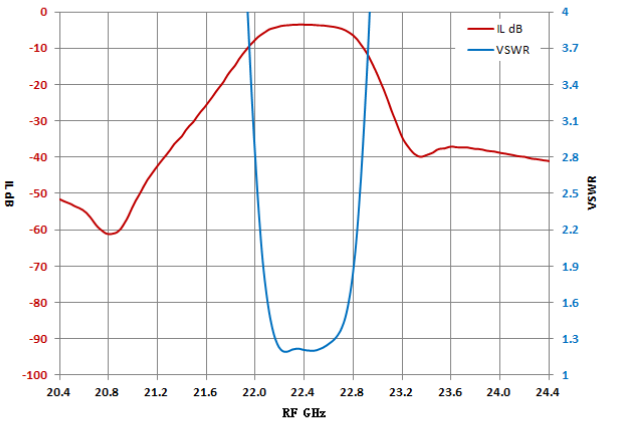


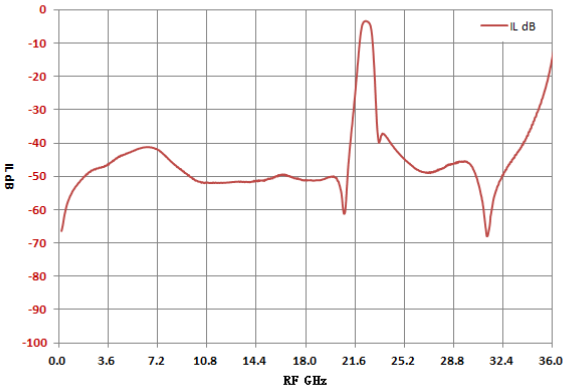
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

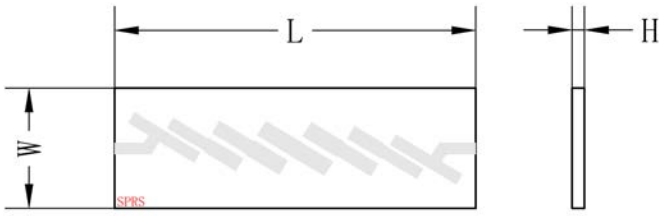
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	22.4	GHz
工作带宽	22.3-22.5	GHz
中心损耗	3.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	35@DC-21.3GHz	dBc
带外抑制	30@23.3-33.0GHz	dBc

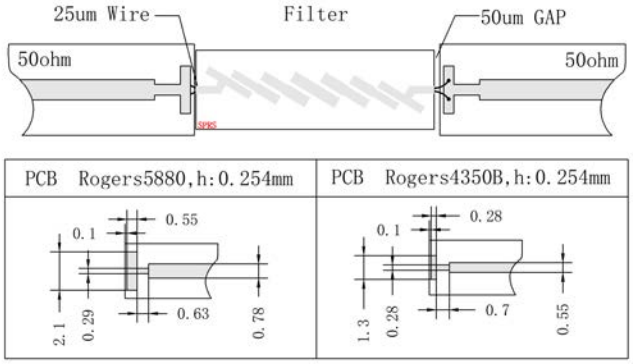
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：4.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

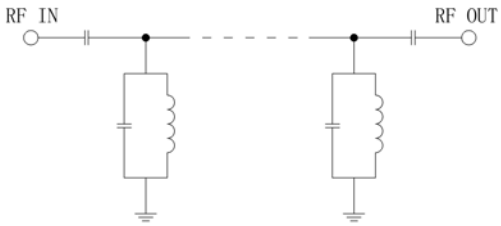
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

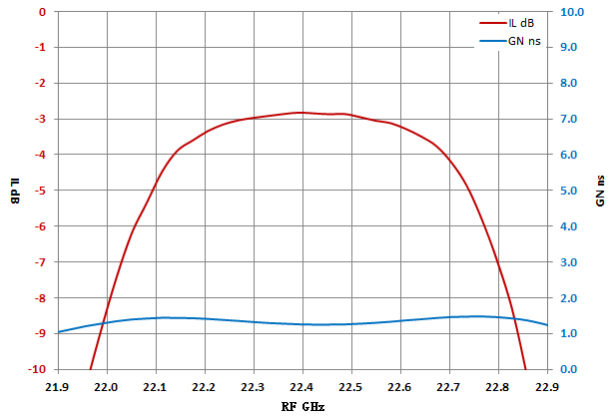
参考图

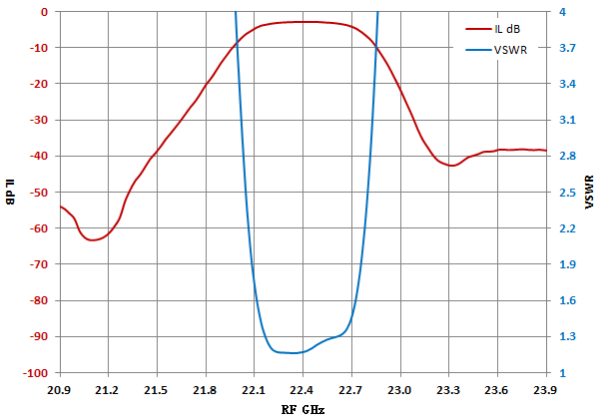


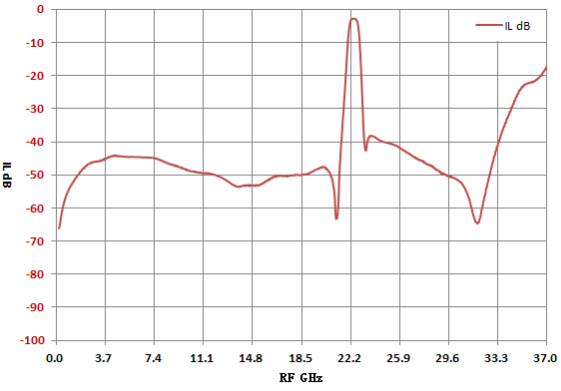
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

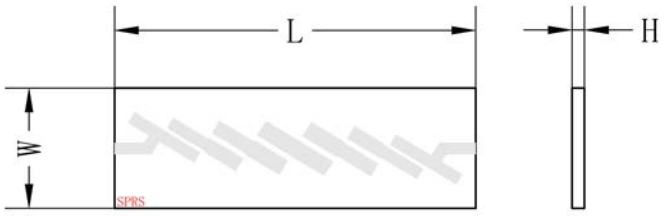
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	22.45	GHz
工作带宽	22.4-22.5	GHz
中心损耗	4.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	30@DC-21.24GHz	dBc
带外抑制	25@23.3-34.0GHz	dBc

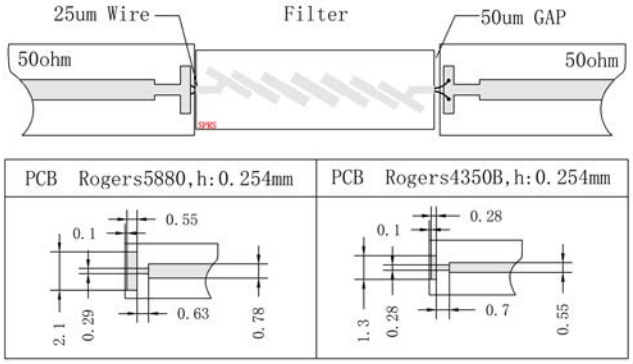
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：4.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

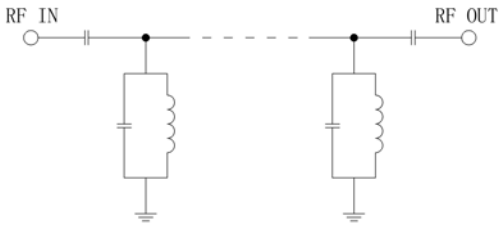
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

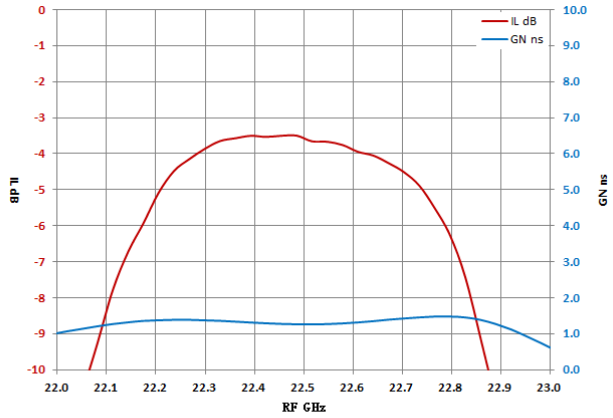
参考图

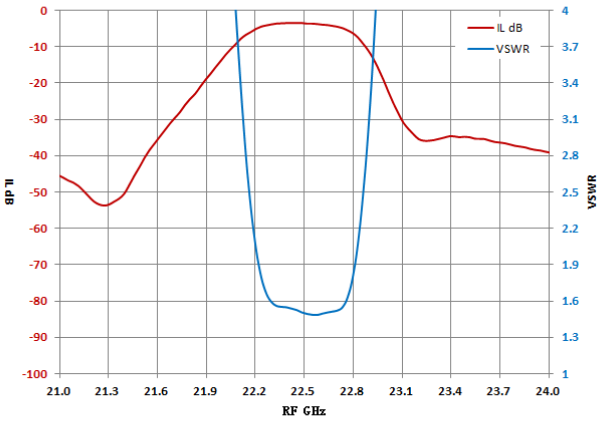


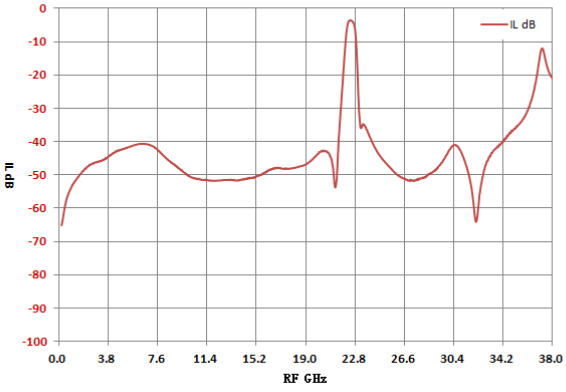
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

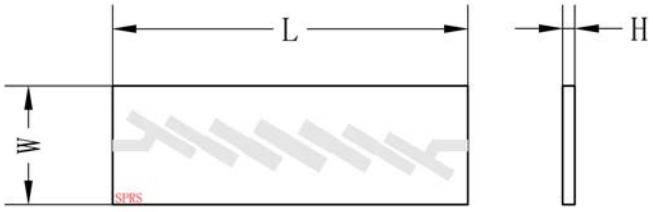
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	22.7	GHz
工作带宽	22.4-23.0	GHz
中心损耗	4.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-21.3GHz	dBc
带外抑制	40@24.2-35.0GHz	dBc

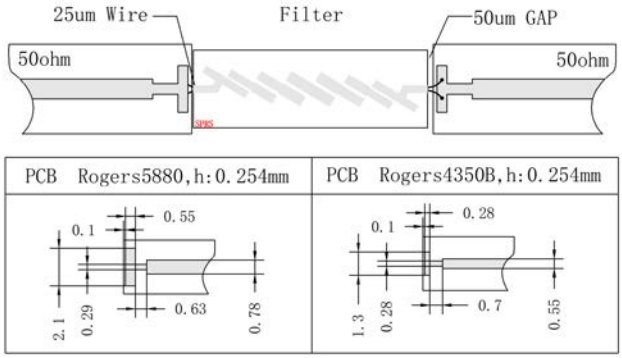
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



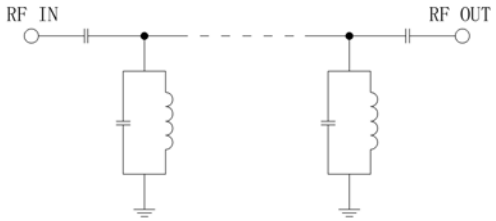
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

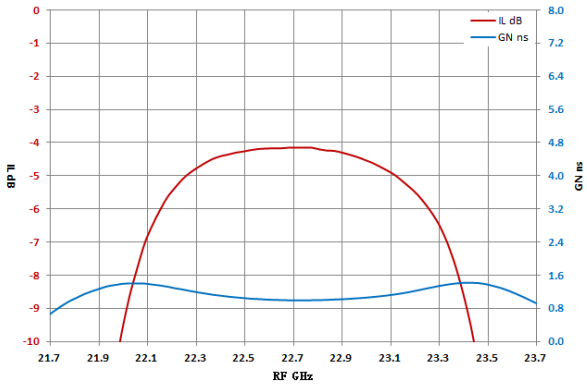
参考实物图

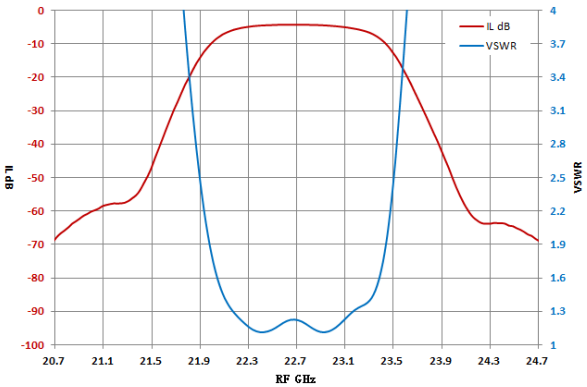


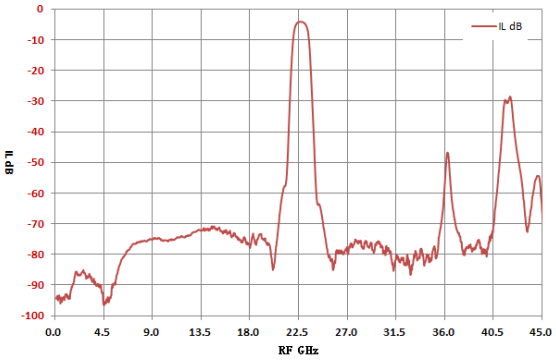
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

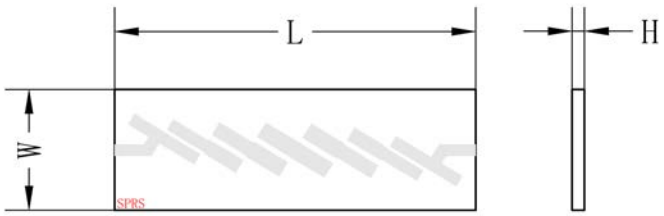
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	22.6	GHz
工作带宽	22.5-22.7	GHz
中心损耗	4.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.5:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	30@DC-21.6GHz	dBc
带外抑制	30@23.7-33.0GHz	dBc

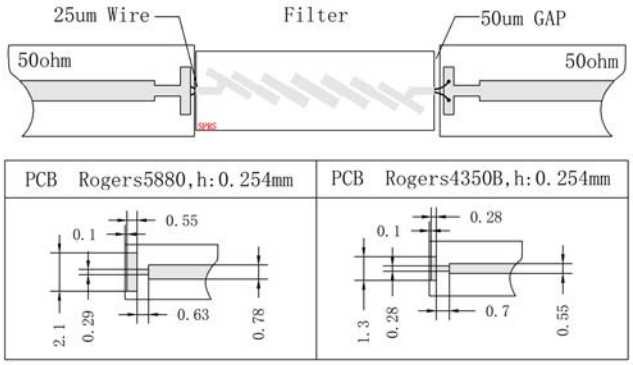
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：4.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

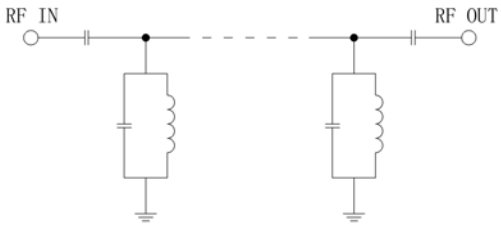
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

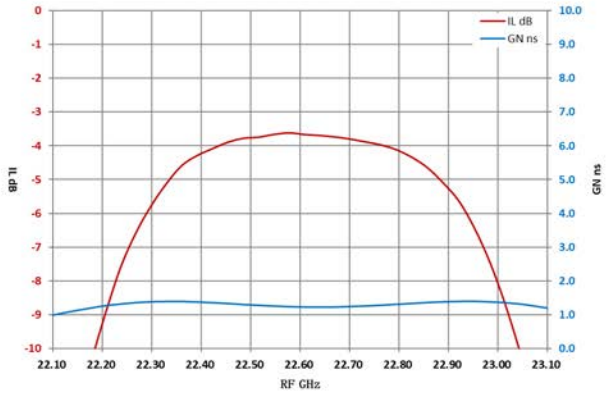
参考图

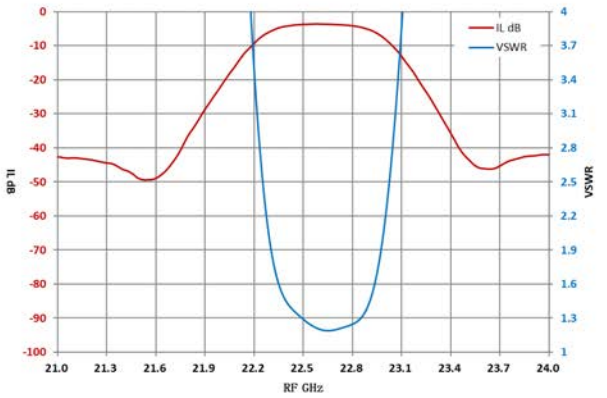


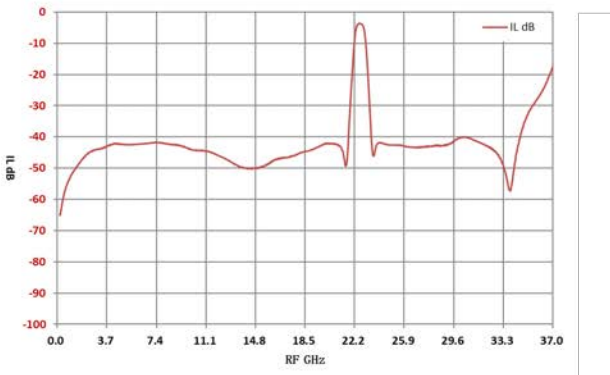
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



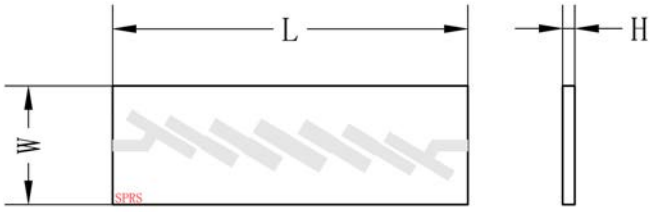
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	22.9	GHz
工作带宽	22.5-23.3	GHz
中心损耗	3.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	35@DC-21.4GHz	dBc
带外抑制	40@24.6-34.0GHz	dBc

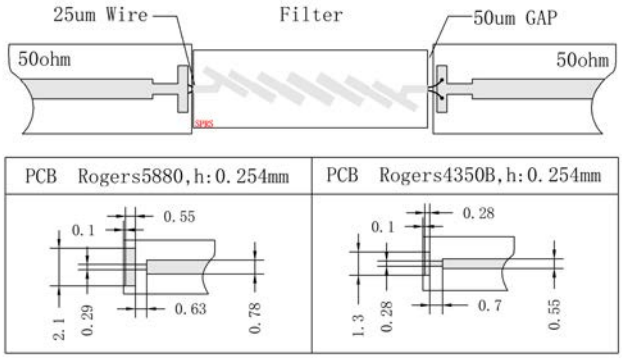
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



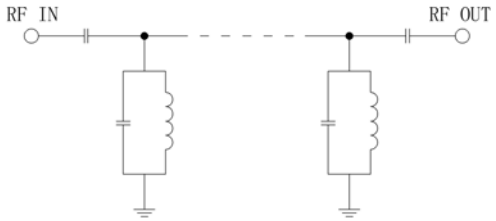
推荐装配图



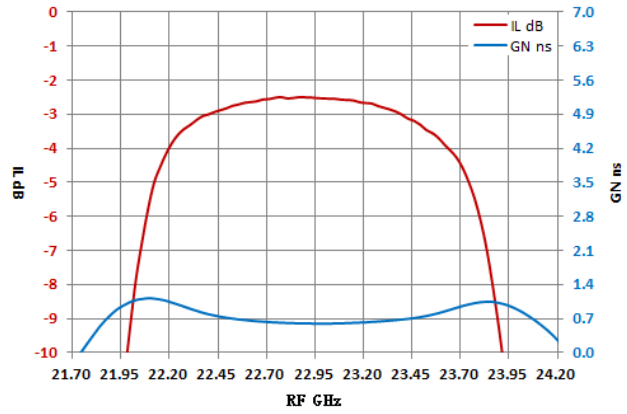
注意事项

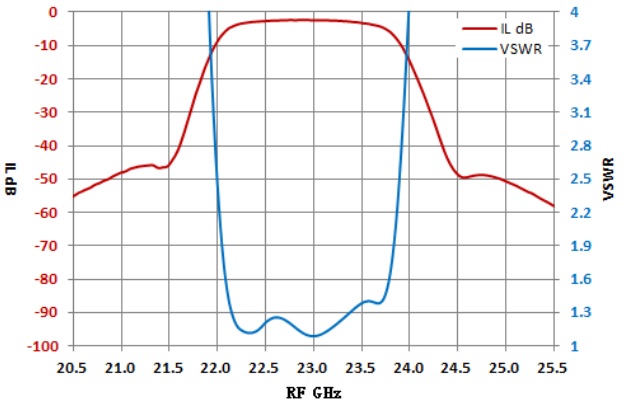
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

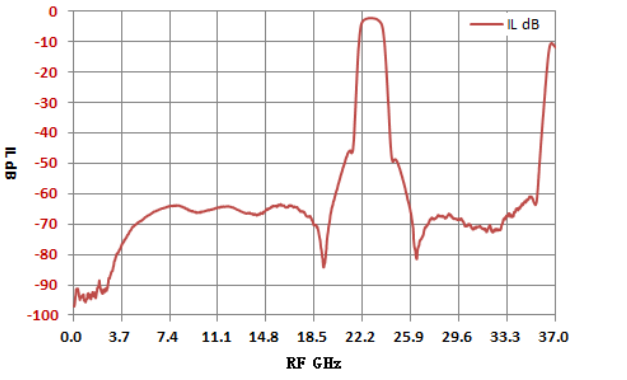
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

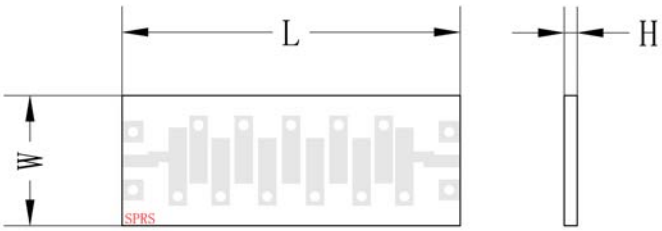
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	32.25	GHz
工作带宽	22.5-42.0	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-17.0GHz	dBc
带外抑制	25@52.0-54.0GHz	dBc

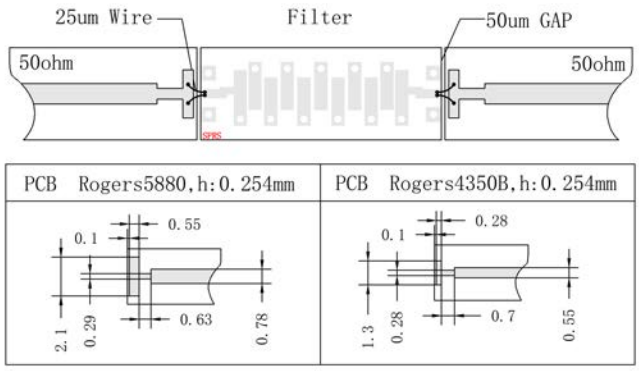
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：5.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

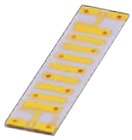
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

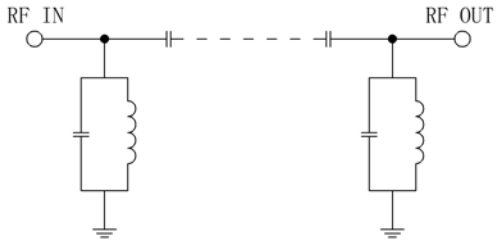
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

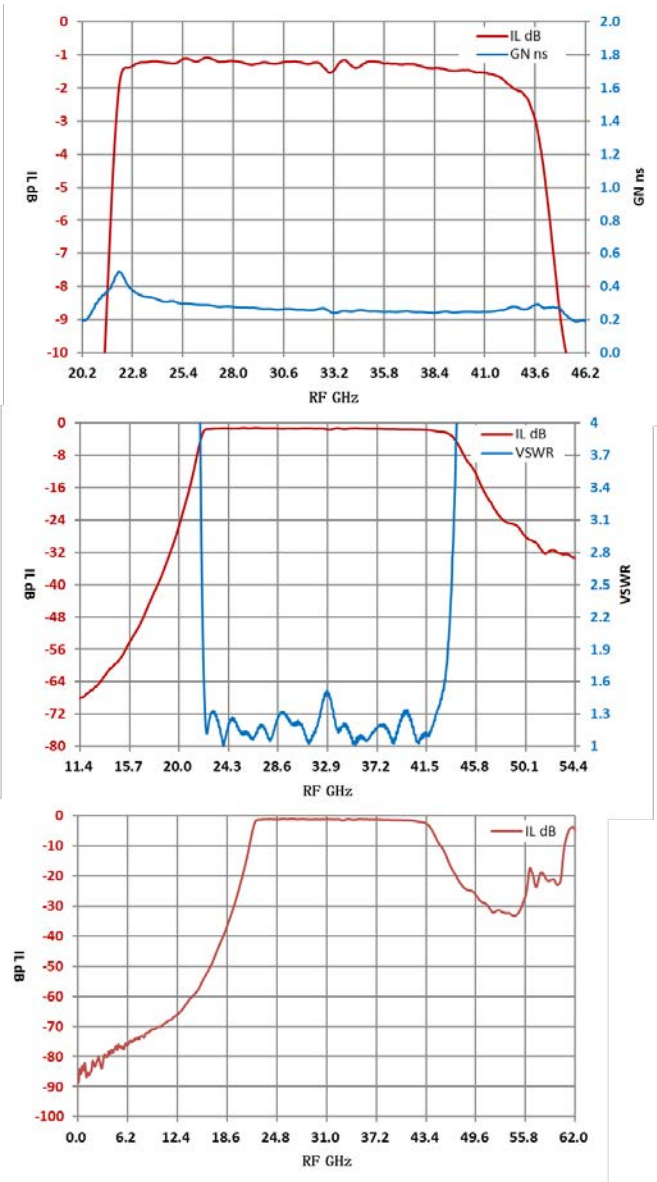
参考图



原理图



典型曲线



产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

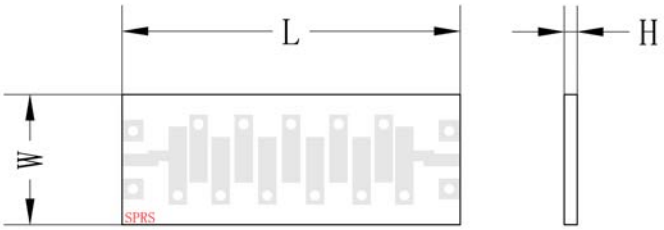
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	24.8	GHz
工作带宽	22.7-26.9	GHz
中心损耗	1.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	50@DC-20.2GHz	dBc
带外抑制	40@29.0-49.0GHz	dBc

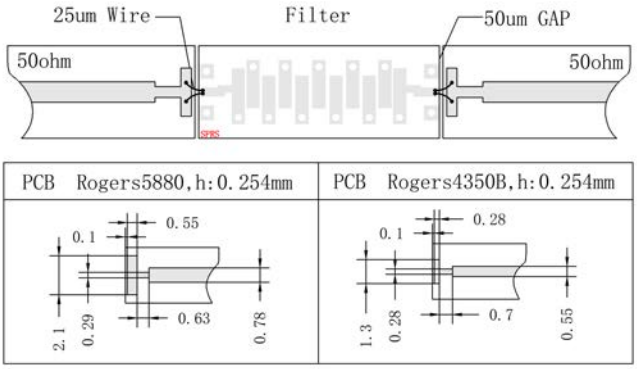
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

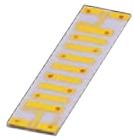
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

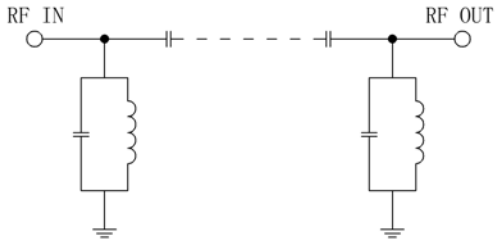
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

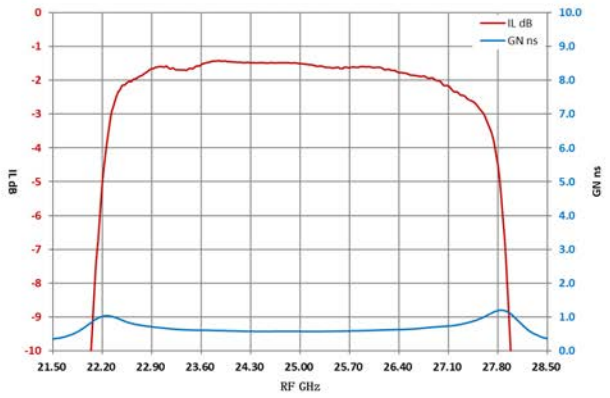
参考图

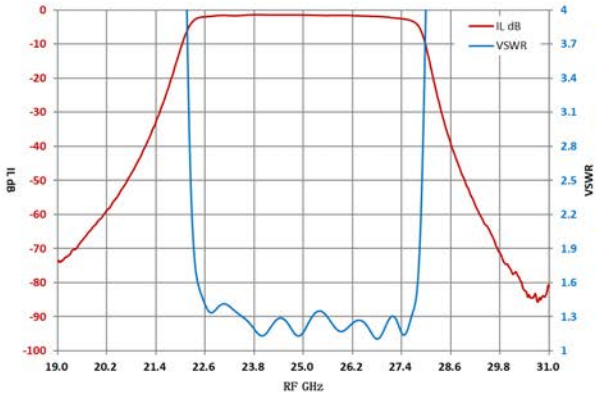


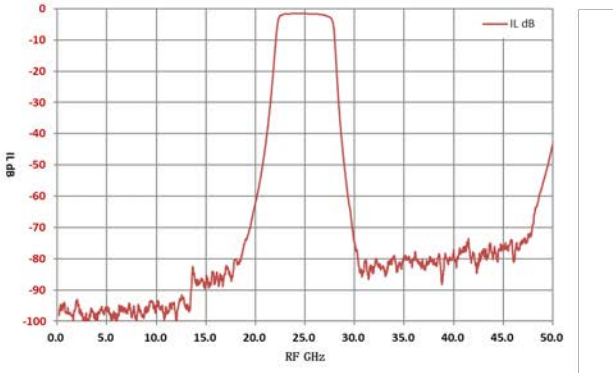
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



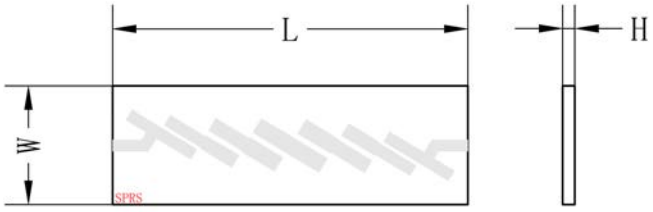
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	25.0	GHz
工作带宽	22.8-27.2	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-20.8GHz	dBc
带外抑制	40@30.2-40.0GHz	dBc

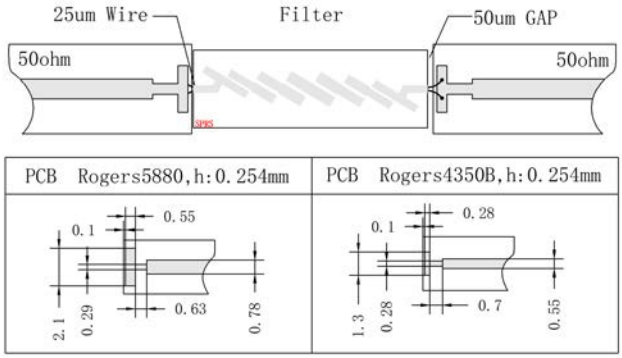
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



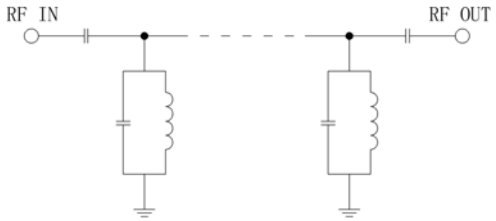
推荐装配图



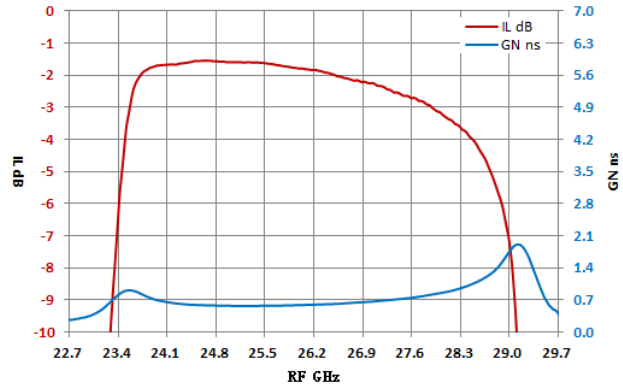
注意事项

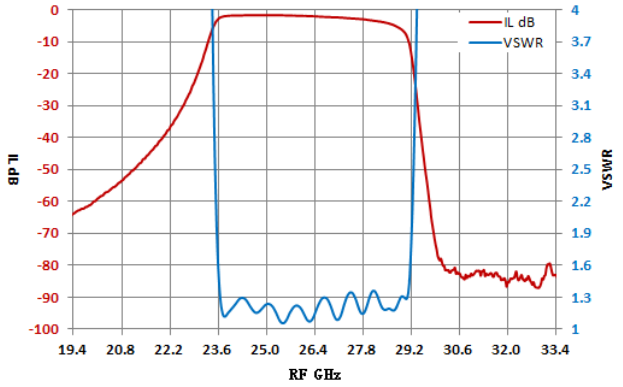
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

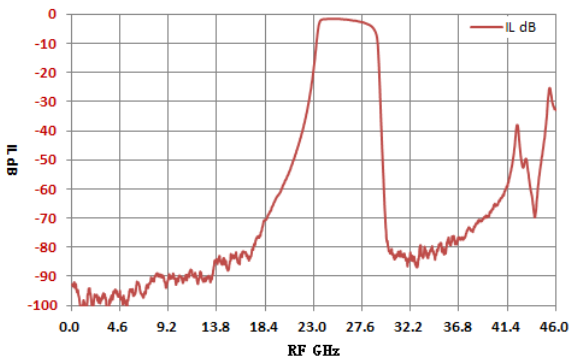
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

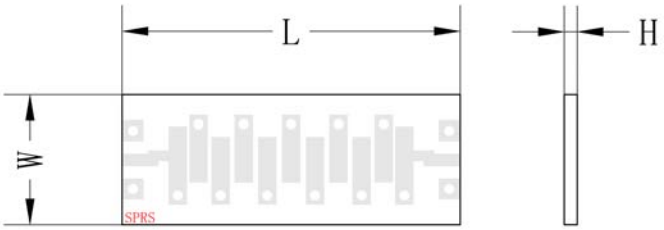
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	25.9	GHz
工作带宽	22.8-29.0	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	60@DC-20.0GHz	dBc
带外抑制	50@32.2-45.0GHz	dBc

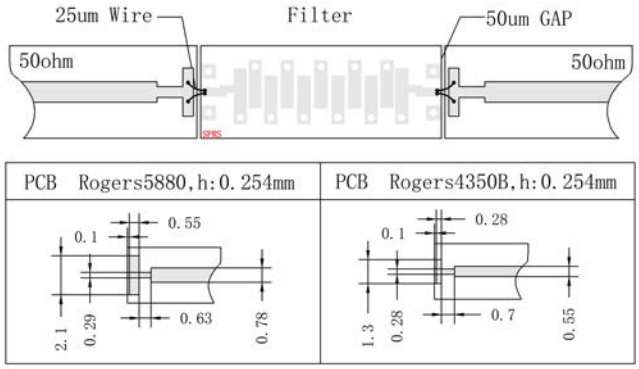
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：6.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

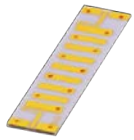
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

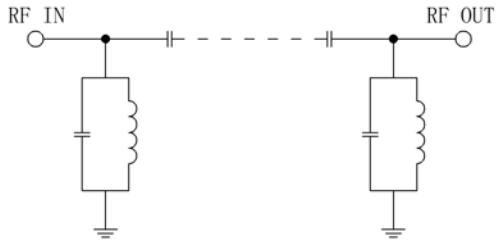
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

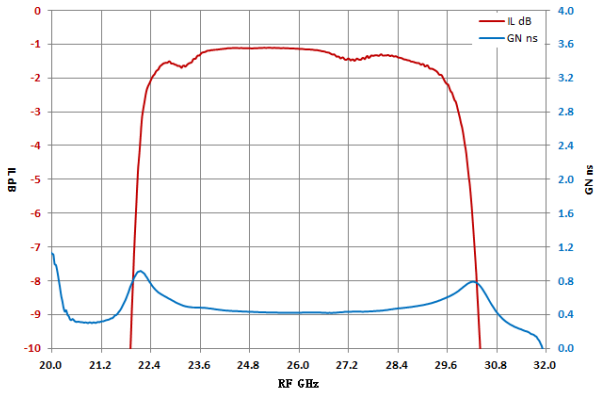
参考图

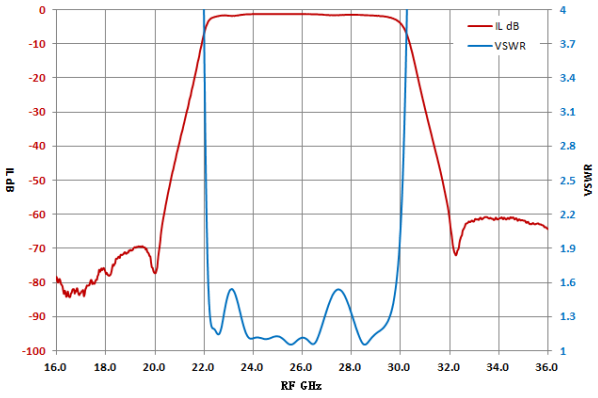


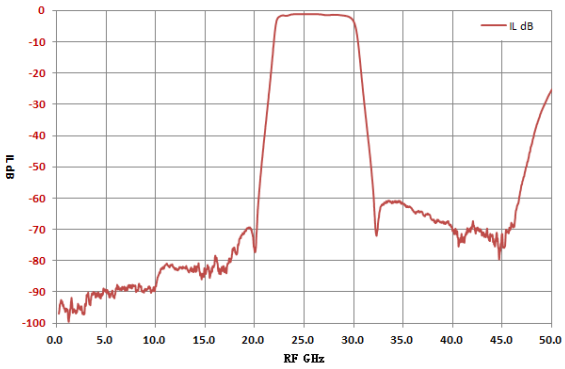
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

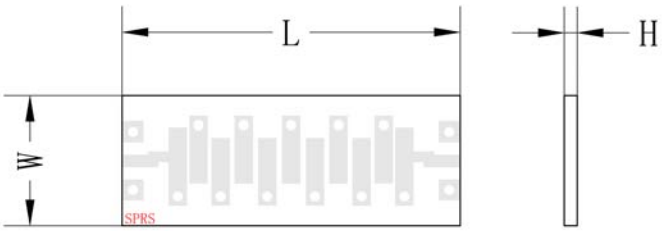
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	26.05	GHz
工作带宽	22.9-29.2	GHz
中心损耗	1.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	50@DC-20.0GHz	dBc
带外抑制	45@32.8-50.0GHz	dBc

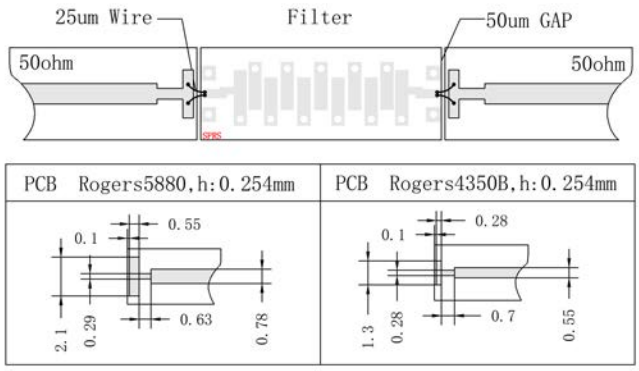
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：6.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

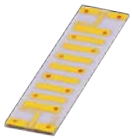
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

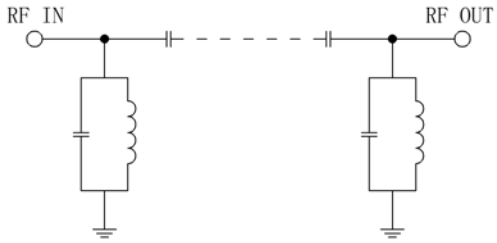
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

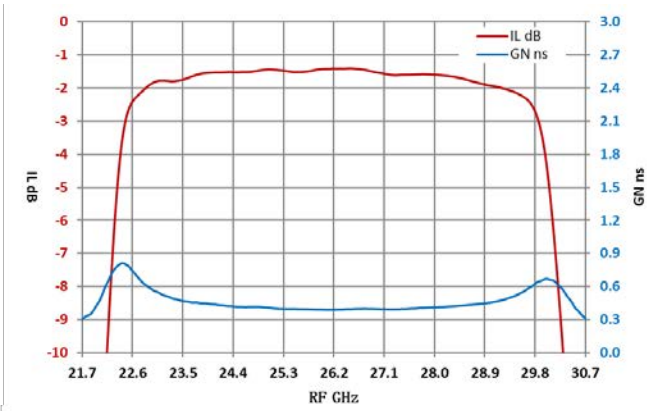
参考图

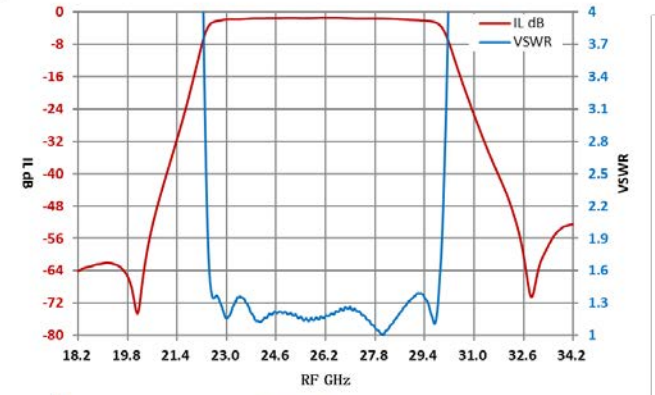


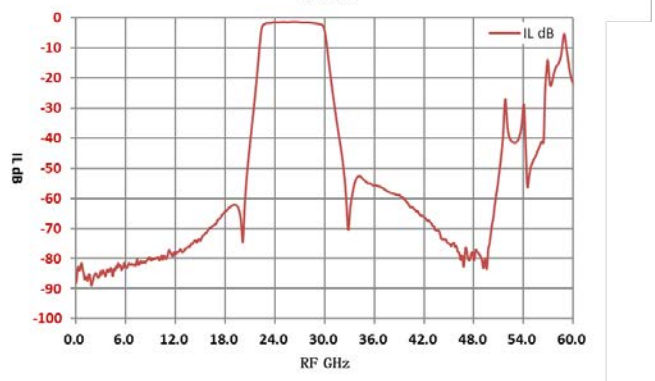
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



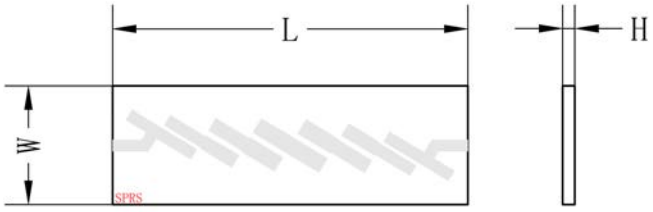
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	26.2	GHz
工作带宽	23.0-29.4	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-19.6GHz	dBc
带外抑制	40@34.5-44.0GHz	dBc

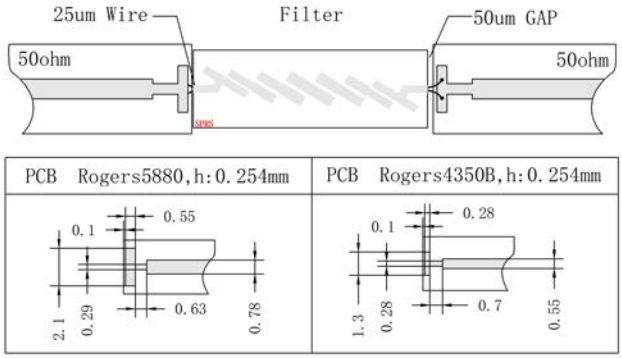
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



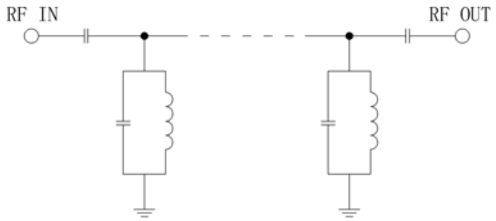
推荐装配图



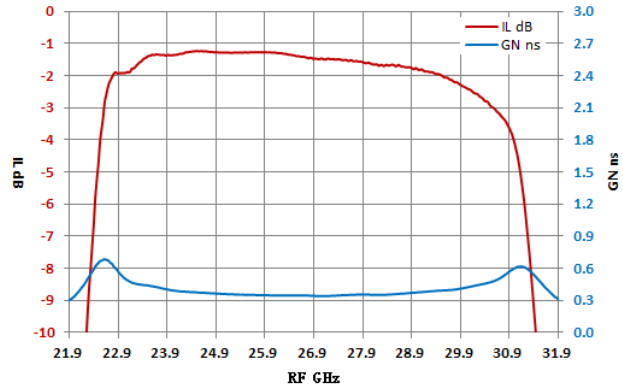
注意事项

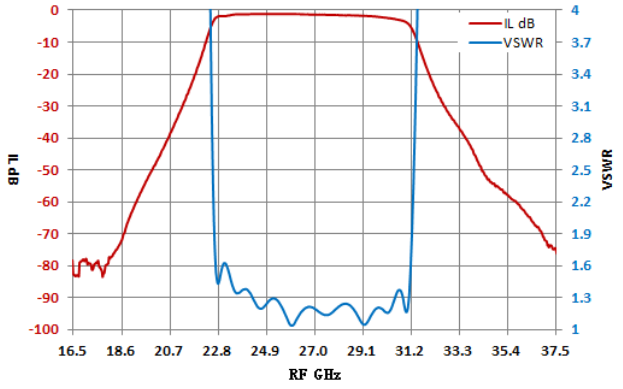
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

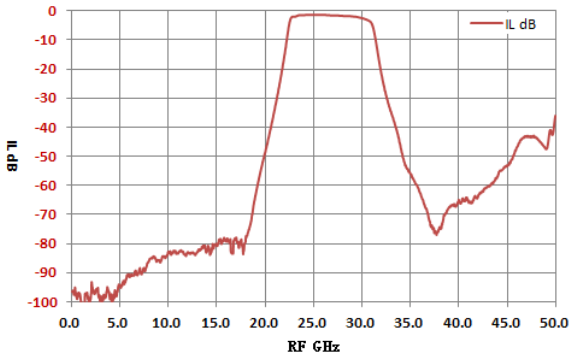
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

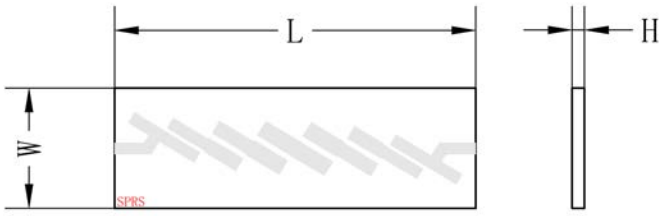
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	30.0	GHz
工作带宽	23.0-37.0	GHz
中心损耗	2.0	dB
带内波动	2.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-19.0GHz	dBc
带外抑制	40@42.0-51.0GHz	dBc

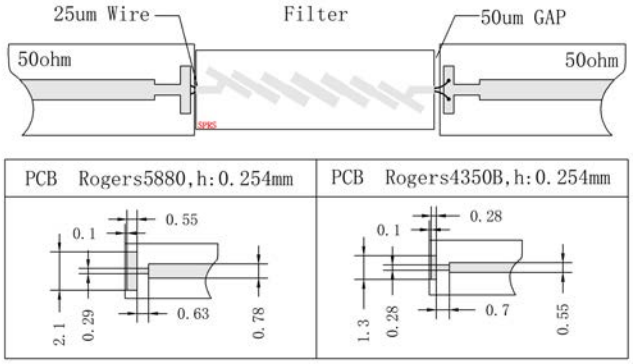
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：9.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

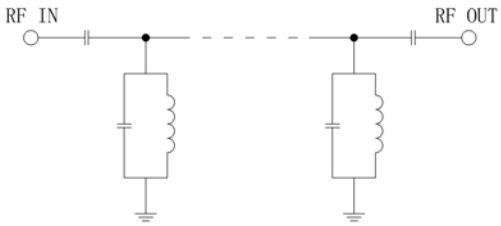
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

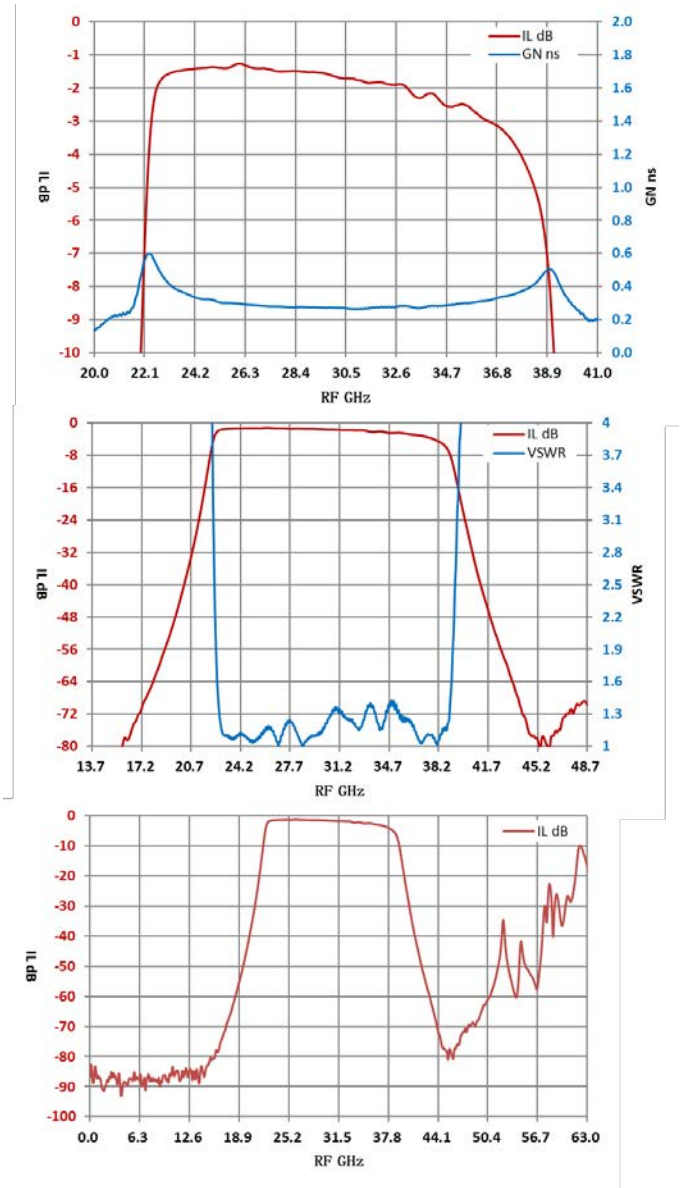
参考图



原理图



典型曲线



产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

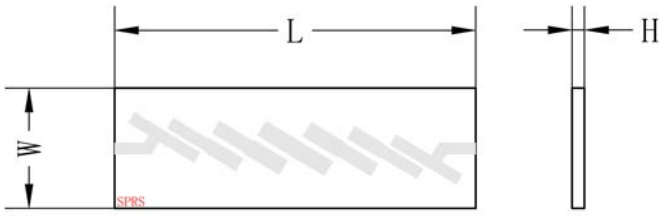
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	23.2	GHz
工作带宽	23.1-23.3	GHz
中心损耗	3.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	35@DC-22.0GHz	dBc
带外抑制	35@24.4-34.0GHz	dBc

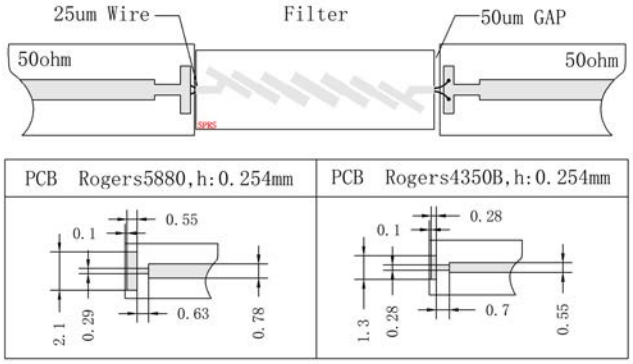
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：4.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

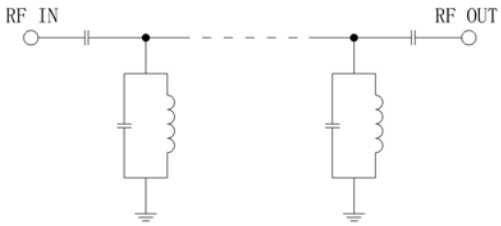
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

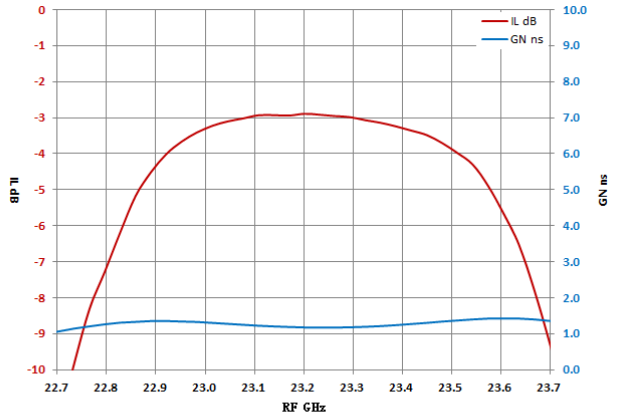
参考图

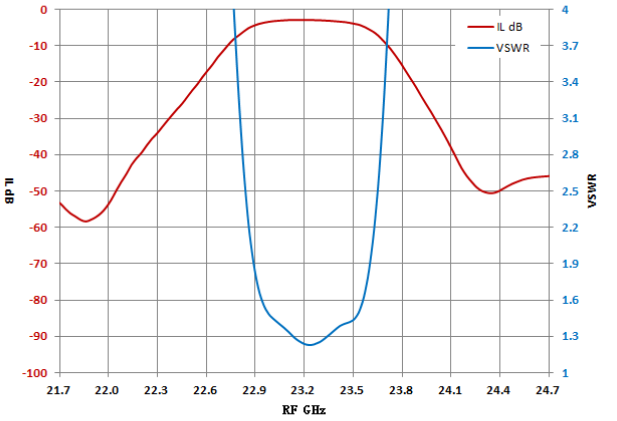


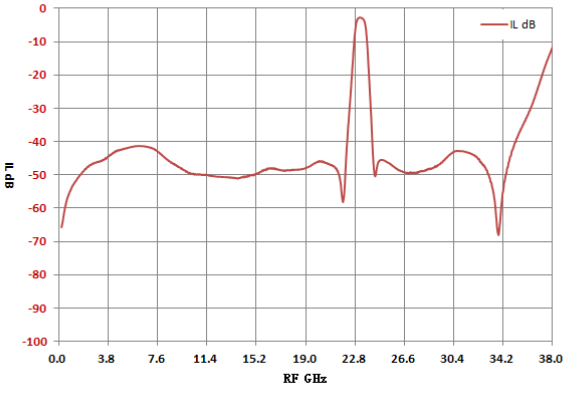
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

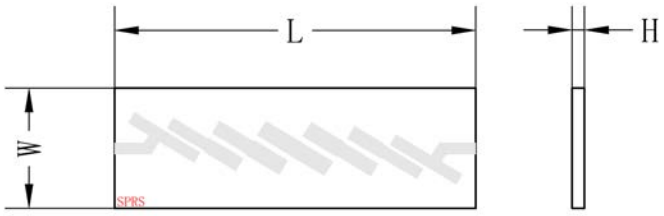
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	23.25	GHz
工作带宽	23.1-23.4	GHz
中心损耗	3.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	30@DC-22.1GHz	dBc
带外抑制	30@24.5-36.0GHz	dBc

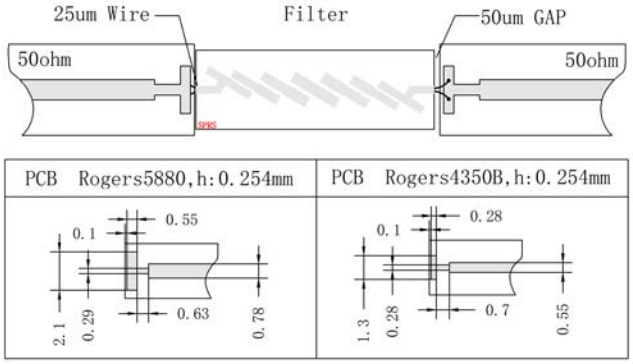
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：4.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

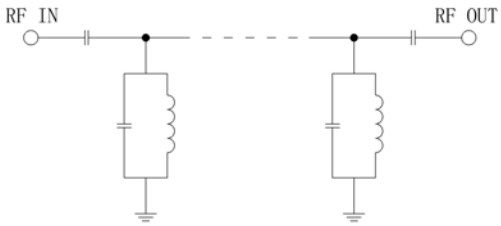
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

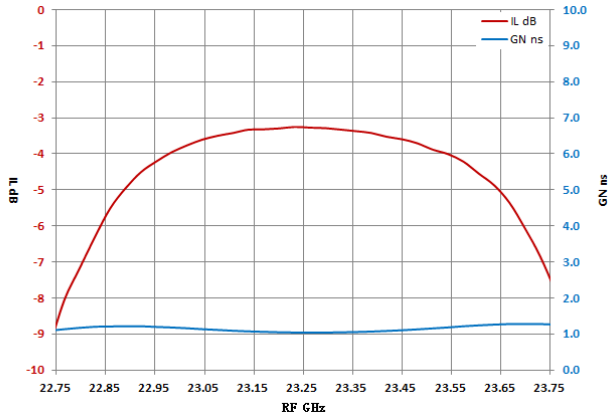
参考图

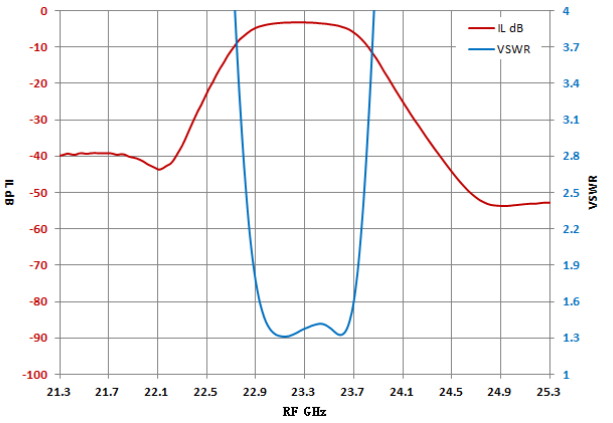


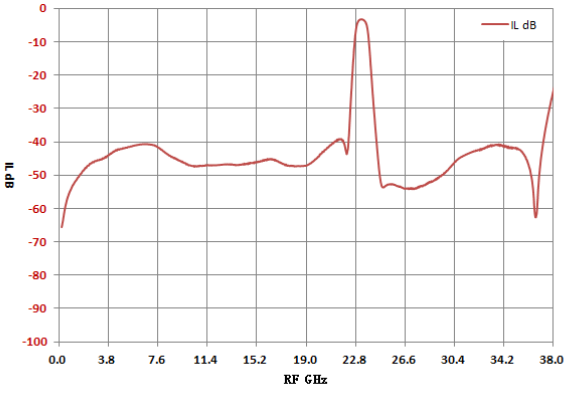
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

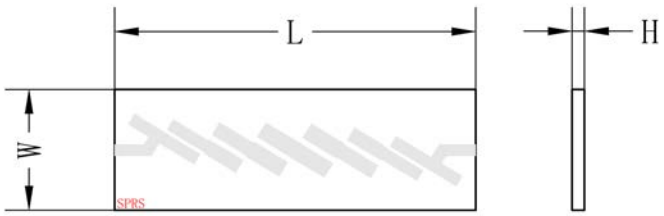
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	24.8	GHz
工作带宽	23.1-26.5	GHz
中心损耗	1.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	60@DC-21.0GHz	dBc
带外抑制	55@29.0-33.0GHz	dBc

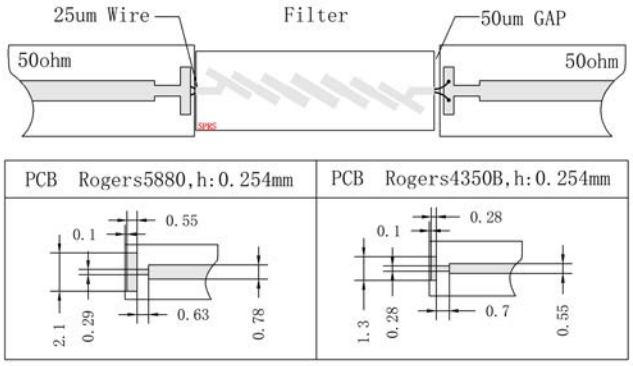
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：7.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

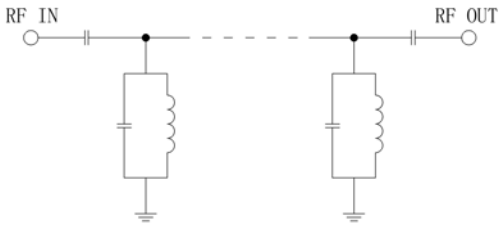
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

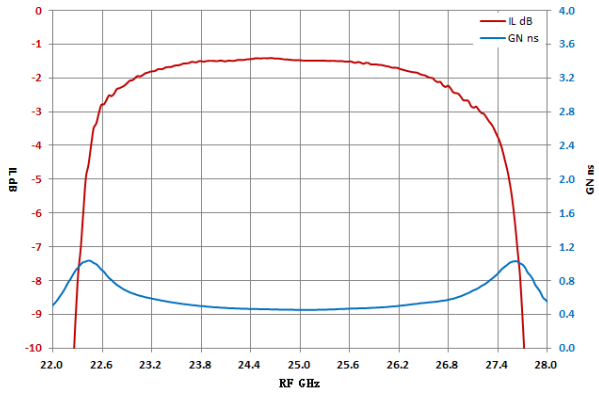
参考图

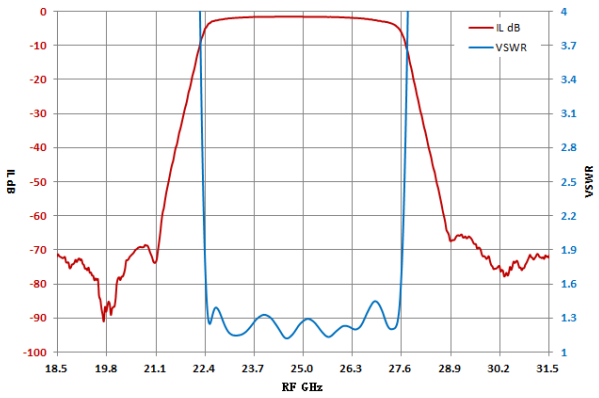


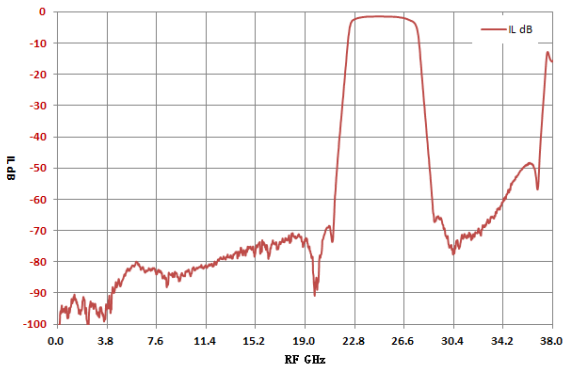
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

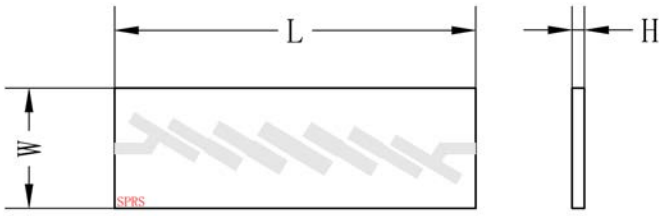
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	23.35	GHz
工作带宽	23.2-23.5	GHz
中心损耗	2.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	35@DC-22.0GHz	dBc
带外抑制	35@24.6-34.0GHz	dBc

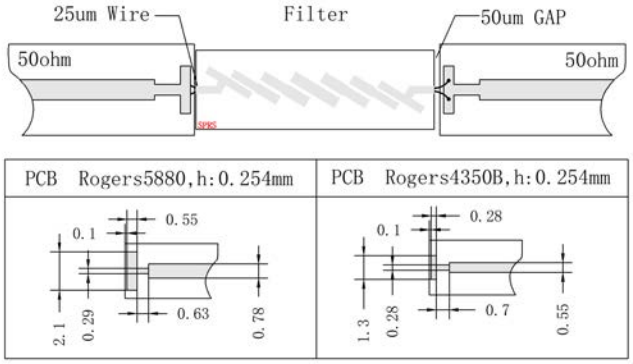
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：4.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

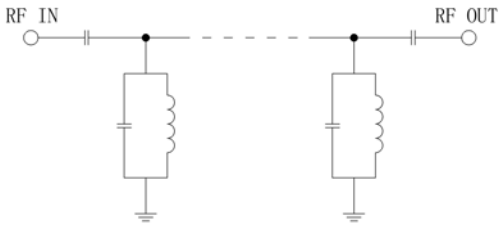
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

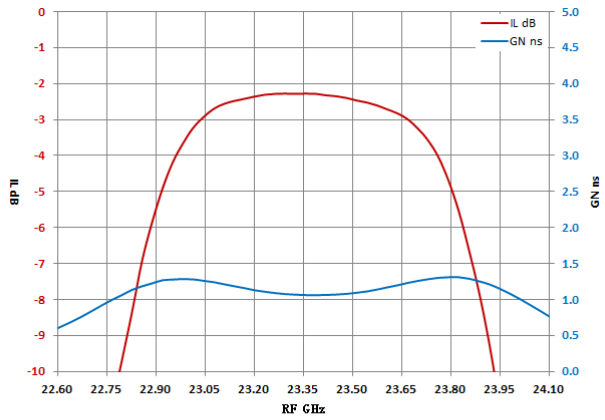
参考图

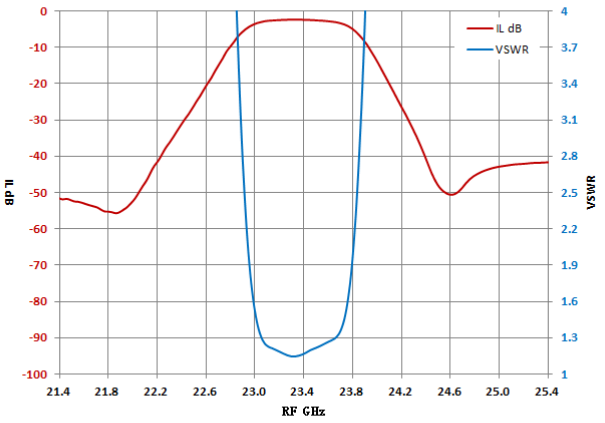


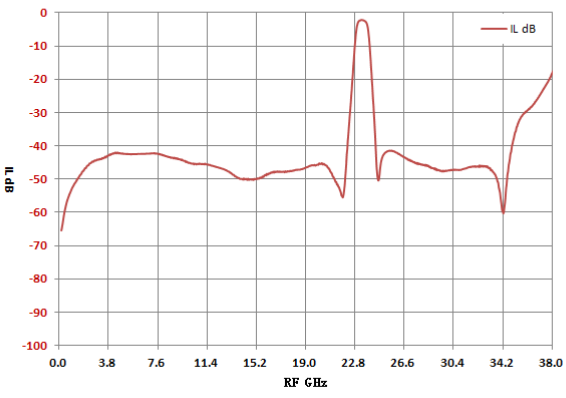
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

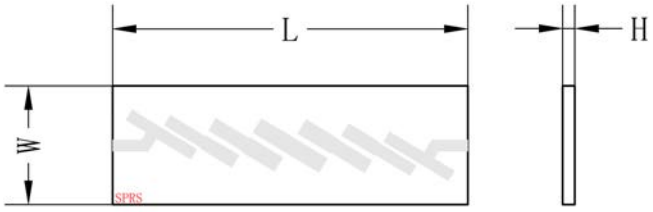
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	24.7	GHz
工作带宽	23.2-26.2	GHz
中心损耗	1.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-21.5GHz	dBc
带外抑制	40@28.0-38.0GHz	dBc

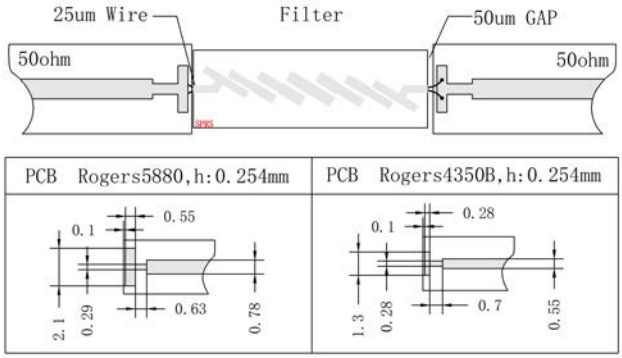
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



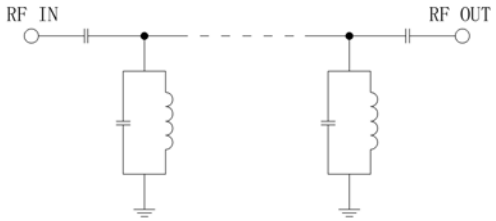
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

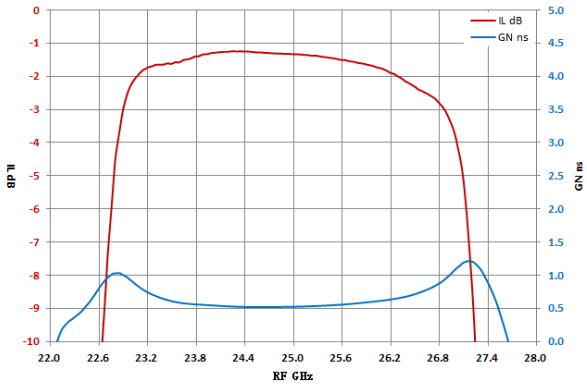
参考实物图

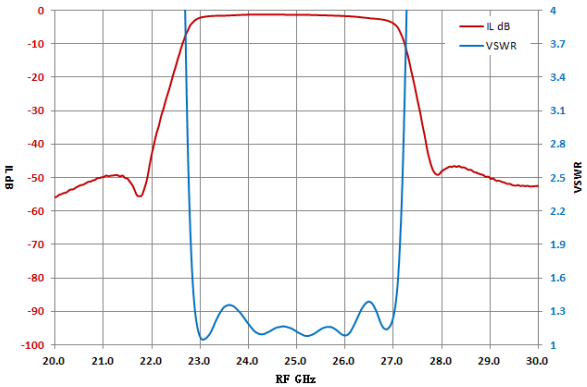


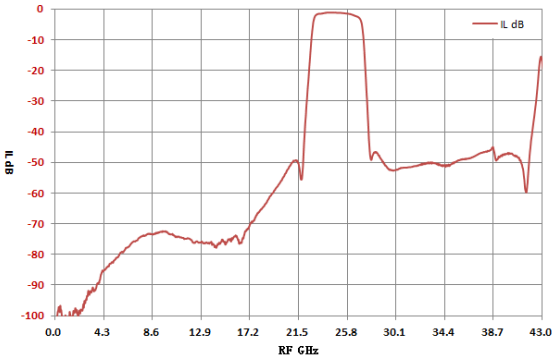
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



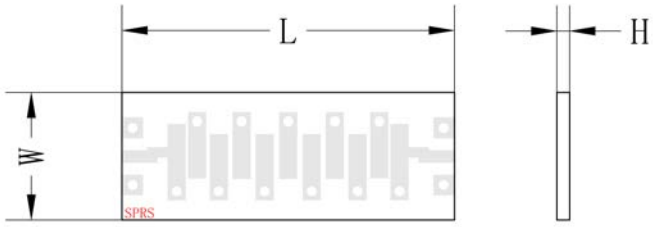
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	27.5	GHz
工作带宽	23.2-31.8	GHz
中心损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-20.4GHz	dBc
带外抑制	40@36.0-45.0GHz	dBc

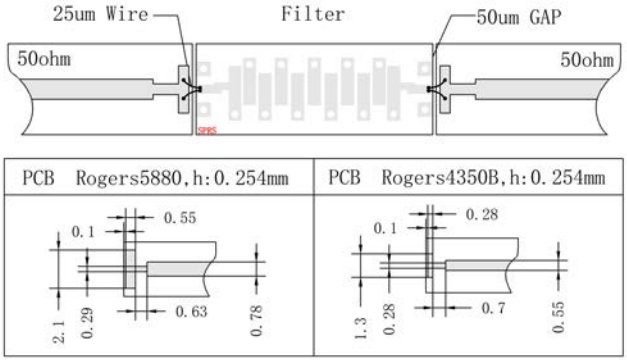
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.0，W：2.8，h：0.26

外形图：端口居中



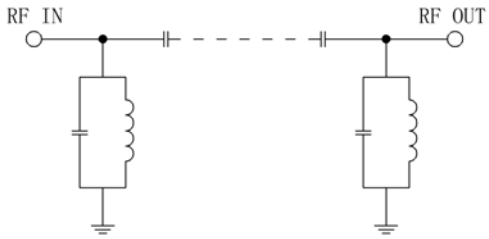
推荐装配图



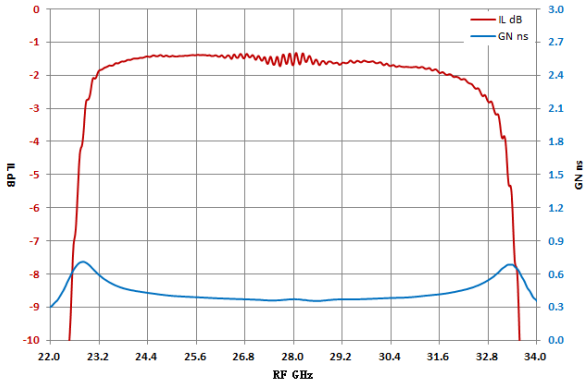
注意事项

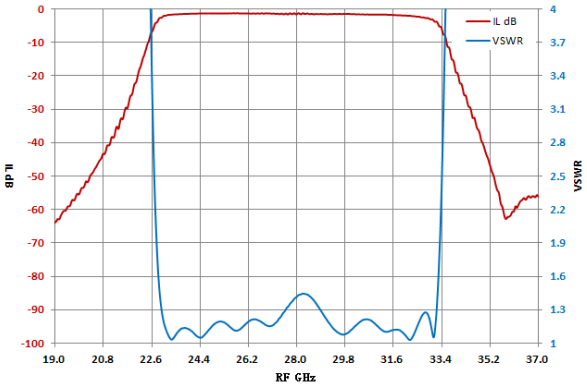
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

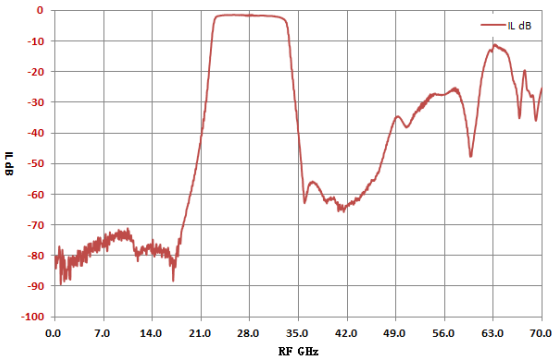
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

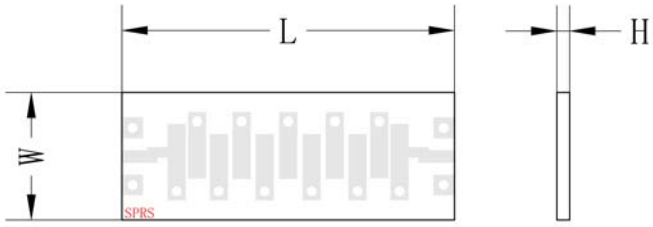
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	26.8	GHz
工作带宽	23.4-30.2	GHz
中心损耗	3.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-19.1GHz	dBc
带外抑制	40@33.3-59.0GHz	dBc

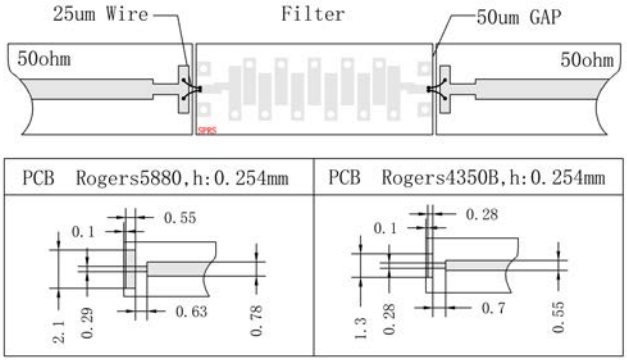
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



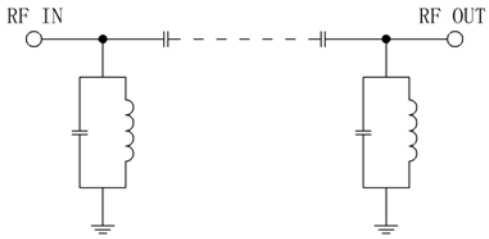
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

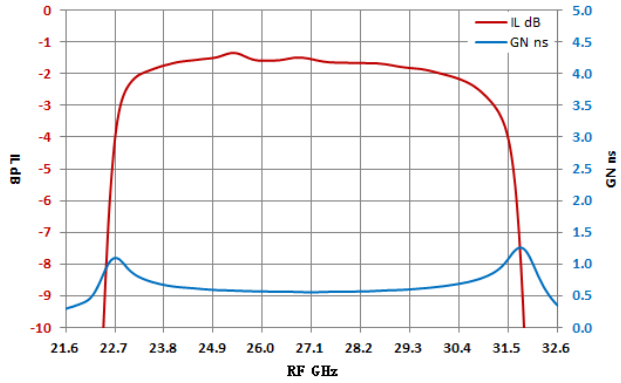
参考实物图

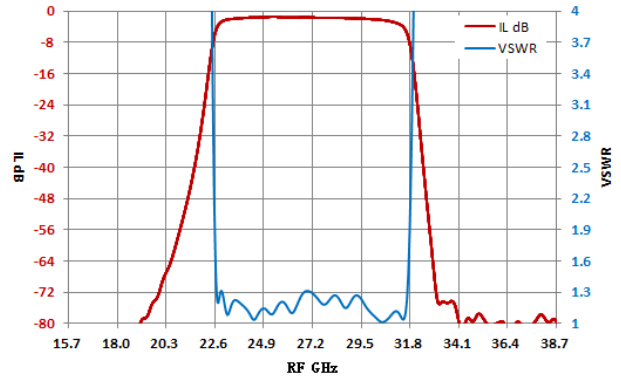


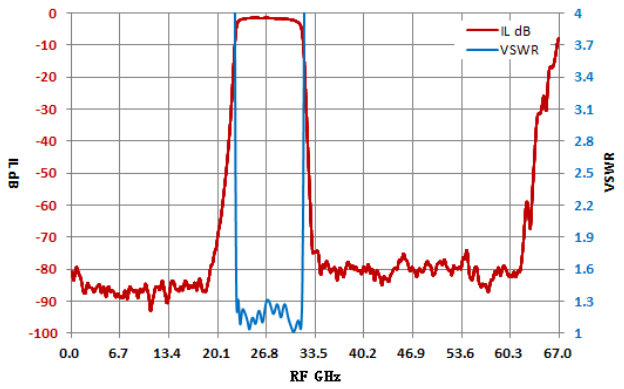
原理图



典型曲线







陶瓷滤波器 STBP279-9R0-M685

工作带宽 23.4-32.4GHz,带外抑制 40@DC-20.2GHz,40@35.2-55.0GHz

产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



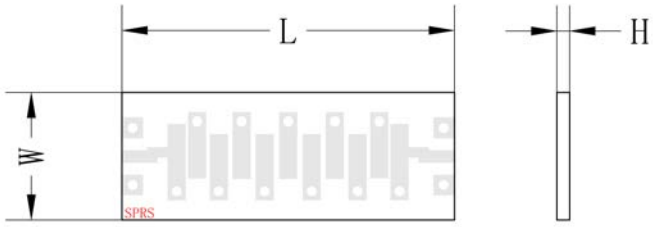
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	27.9	GHz
工作带宽	23.4-32.4	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-20.2GHz	dBc
带外抑制	40@35.2-55.0GHz	dBc

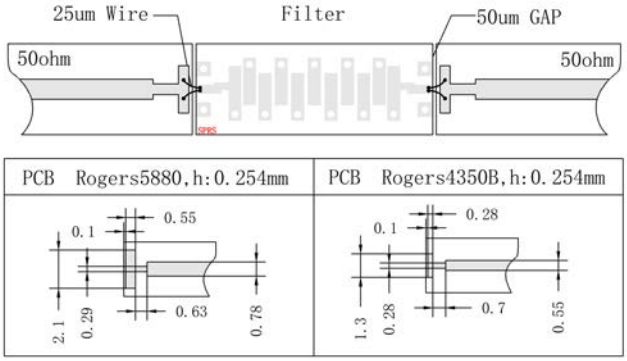
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



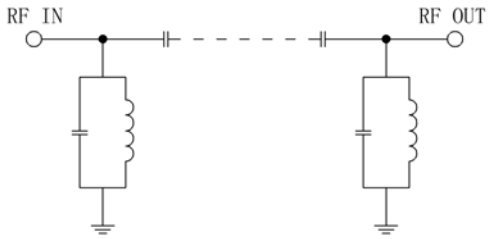
推荐装配图



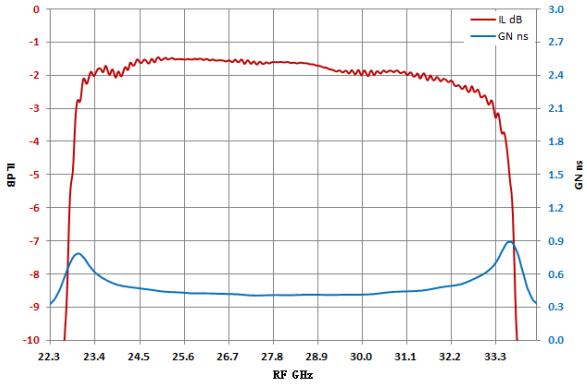
注意事项

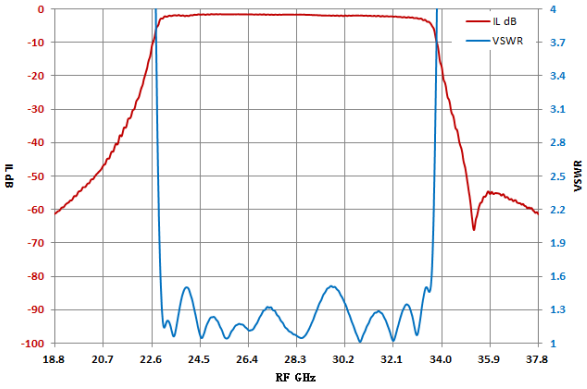
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

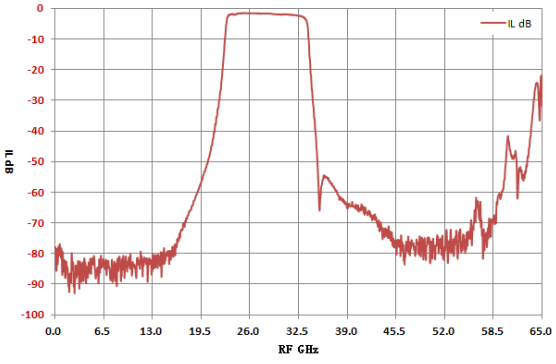
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



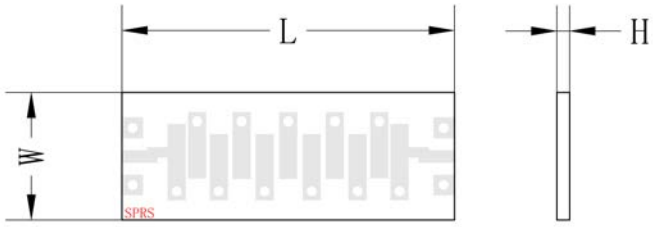
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	28.0	GHz
工作带宽	23.4-32.6	GHz
中心损耗	1.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-19.0GHz	dBc
带外抑制	40@35.4-46.0GHz	dBc

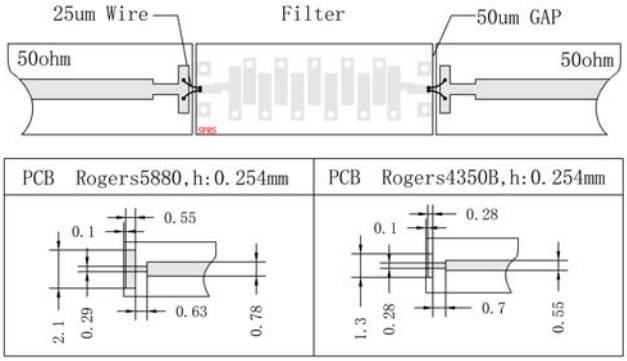
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



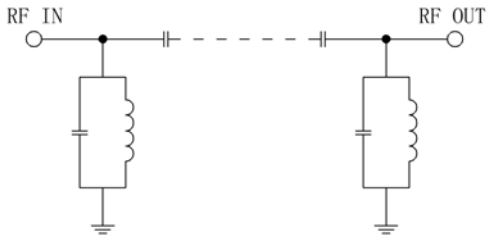
推荐装配图



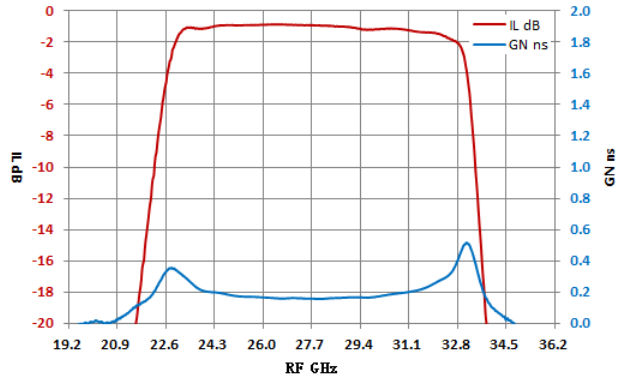
注意事项

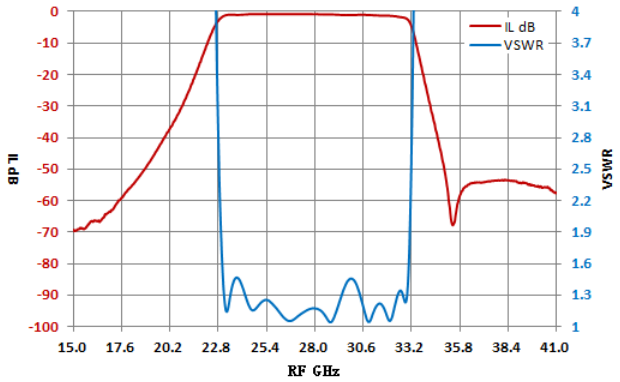
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

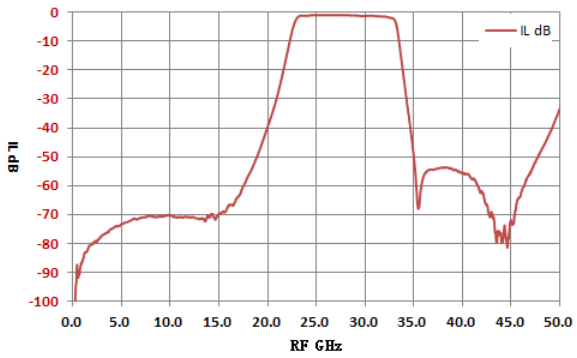
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

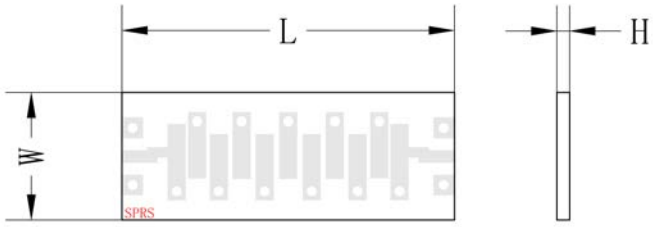
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	28.0	GHz
工作带宽	23.4-32.6	GHz
中心损耗	3.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	1.0	ns
带外抑制	40@DC-18.2.0GHz	dBc
带外抑制	40@35.7-56.0GHz	dBc

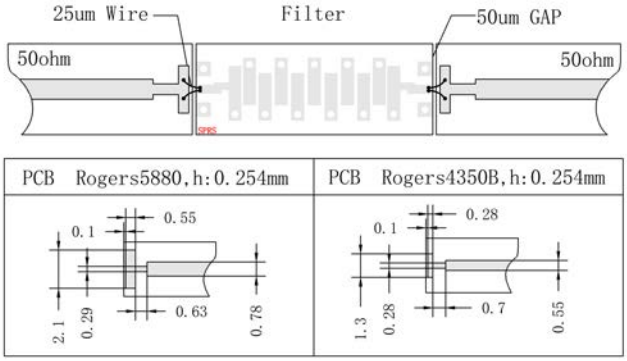
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



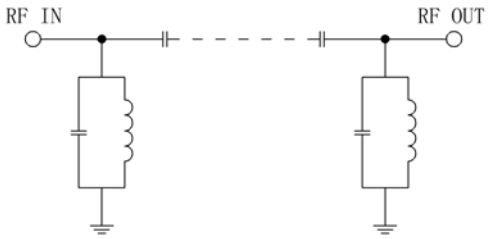
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

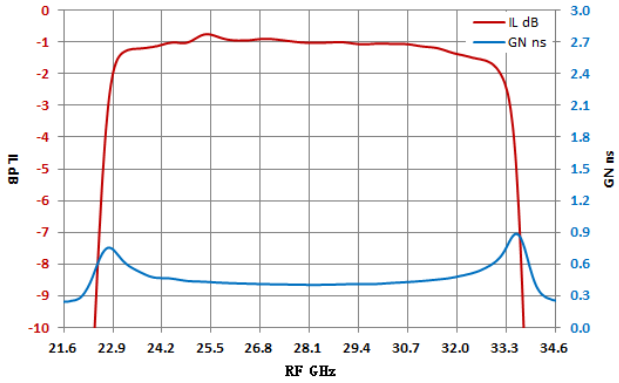
参考实物图

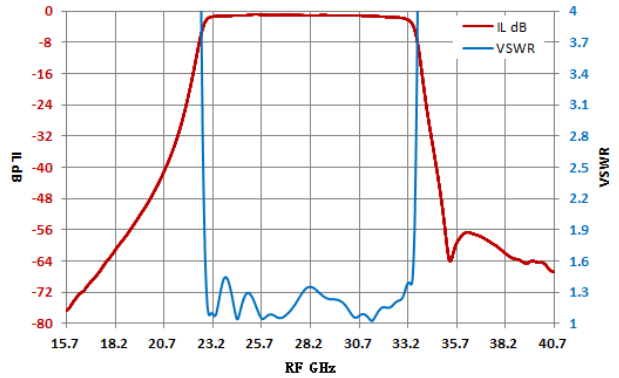


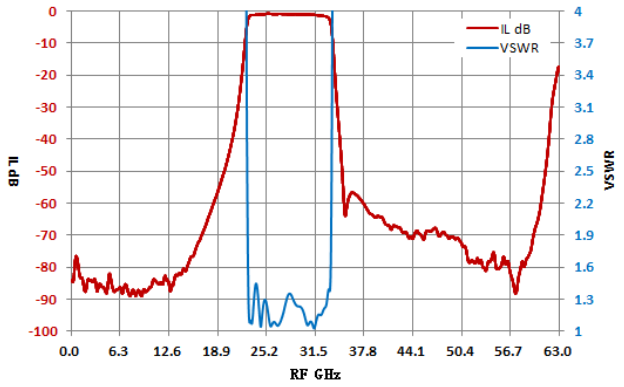
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



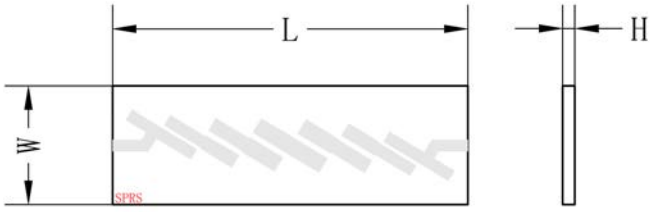
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	24.0	GHz
工作带宽	23.5-24.5	GHz
中心损耗	2.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-22.4GHz	dBc
带外抑制	40@25.9-34.0GHz	dBc

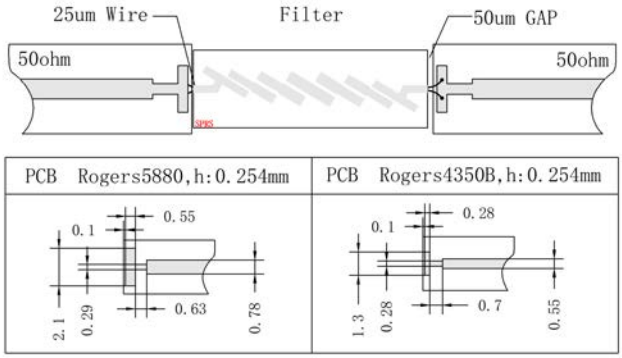
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



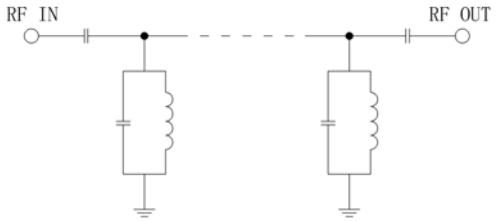
推荐装配图



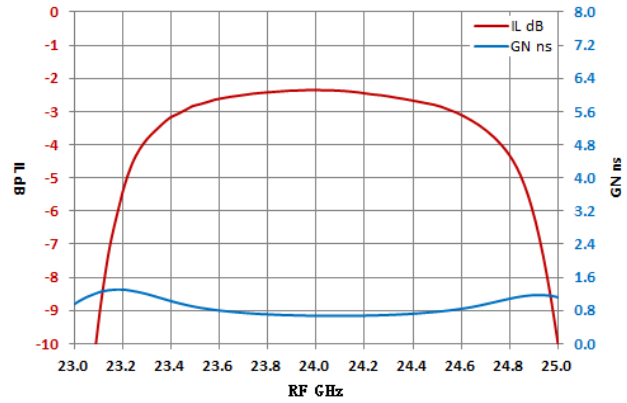
注意事项

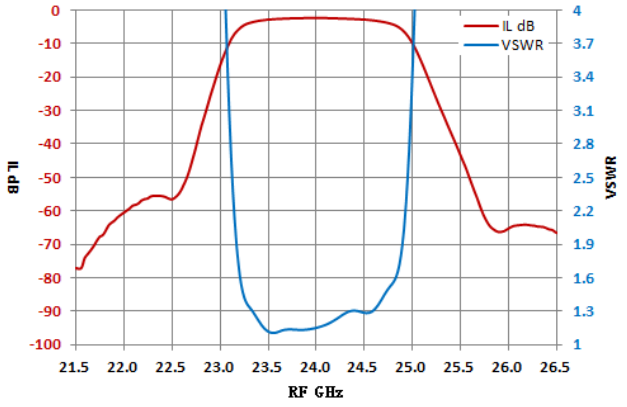
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

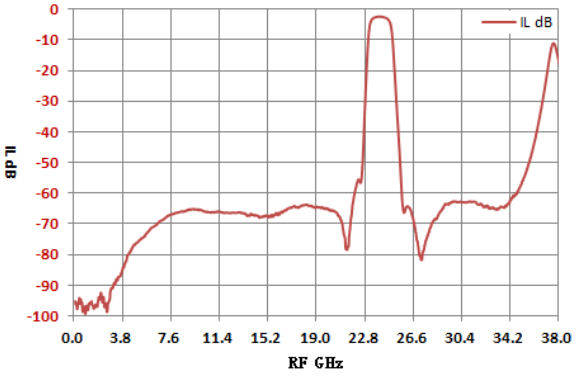
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

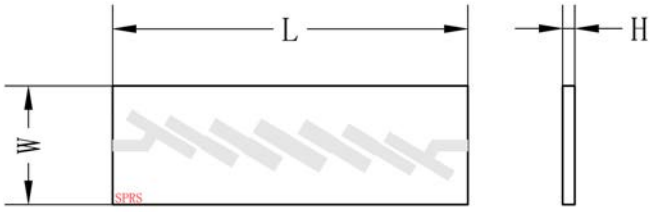
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	26.5	GHz
工作带宽	23.5-29.5	GHz
中心损耗	1.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-20.0GHz	dBc
带外抑制	40@33.0-38.0GHz	dBc

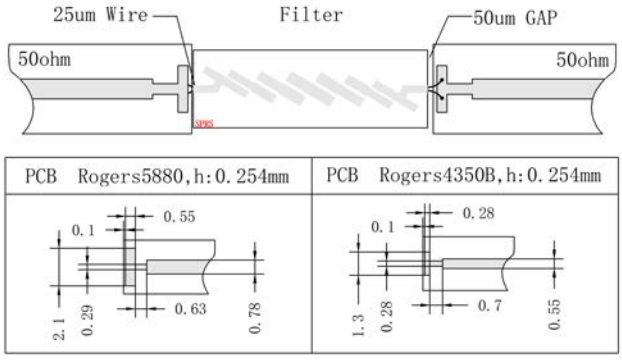
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



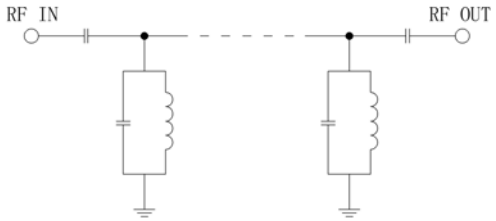
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

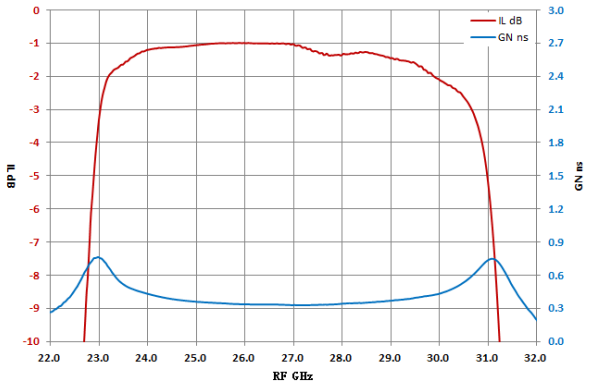
参考实物图

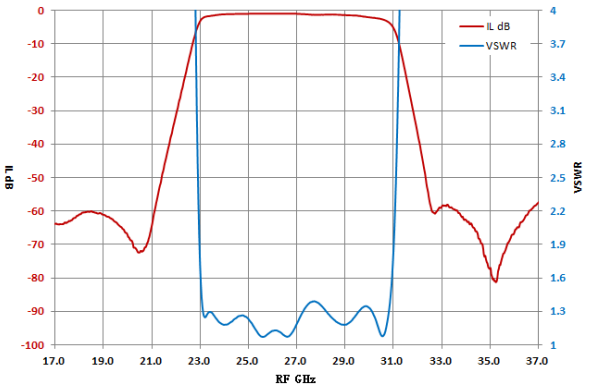


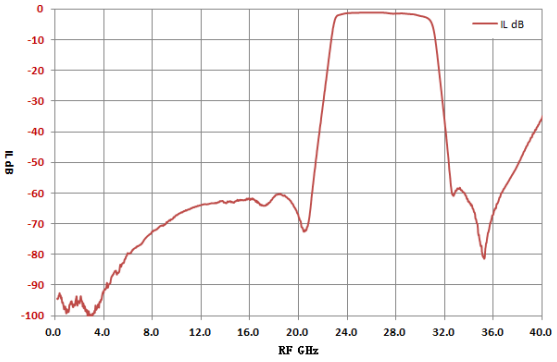
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

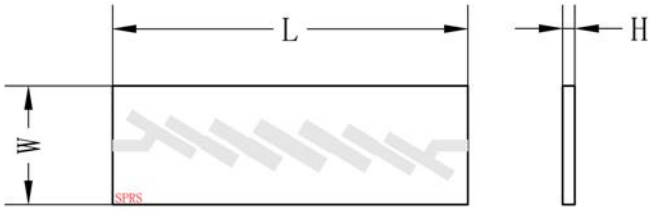
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	28.7	GHz
工作带宽	23.5-33.9	GHz
中心损耗	2.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-20.3GHz	dBc
带外抑制	40@38.9-48.0GHz	dBc

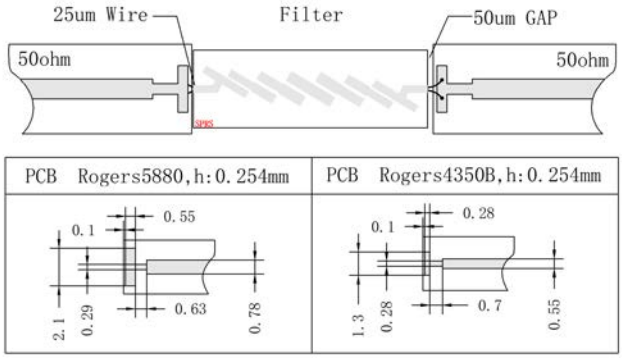
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



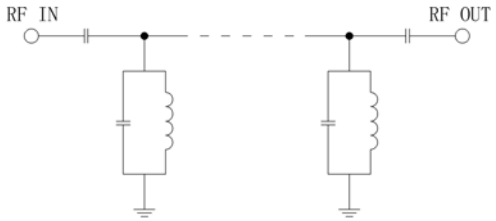
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

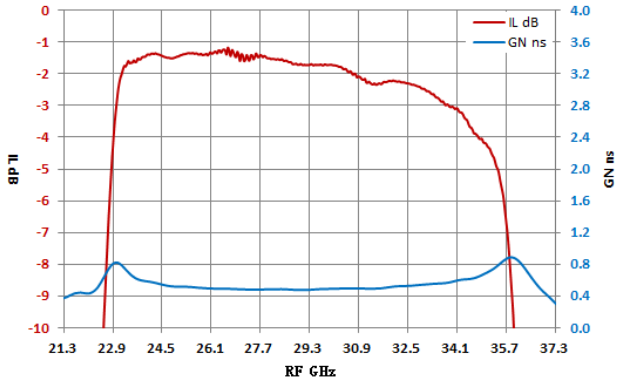
参考实物图

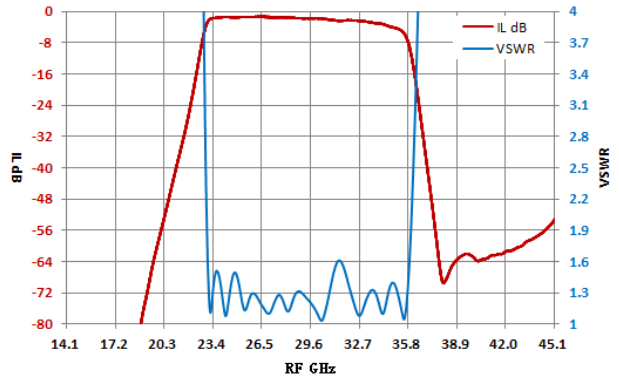


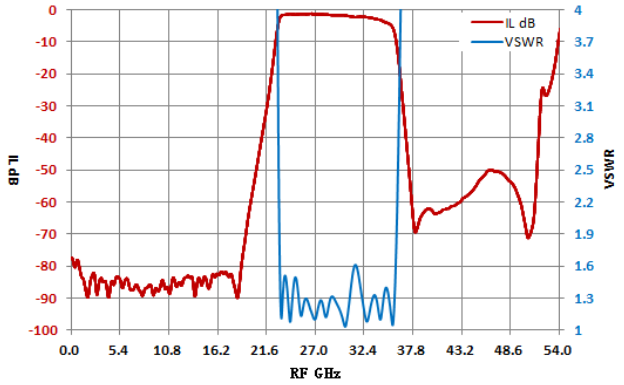
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

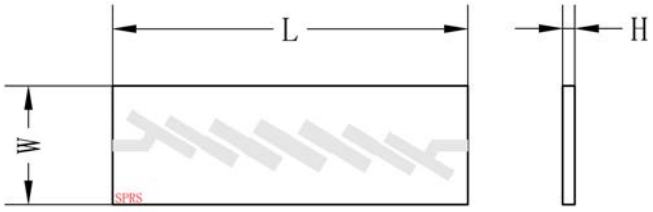
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	26.7	GHz
工作带宽	23.7-29.7	GHz
中心损耗	1.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-6.0GHz	dBc
带外抑制	40@10.2-19.0GHz	dBc

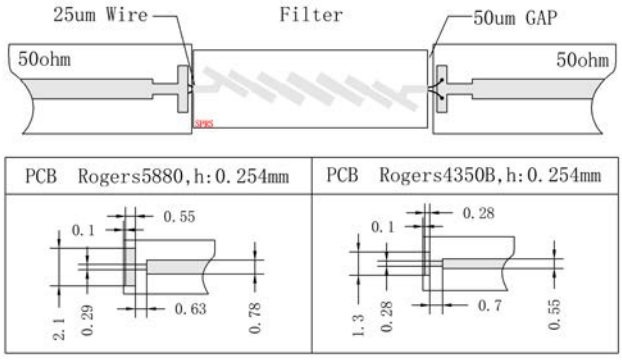
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



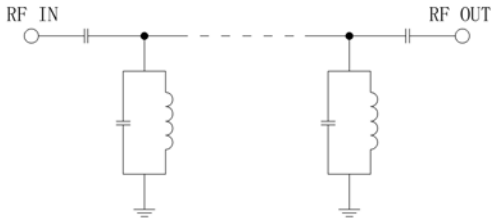
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

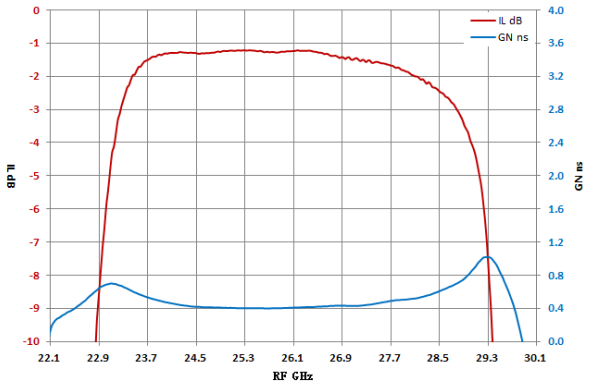
参考实物图

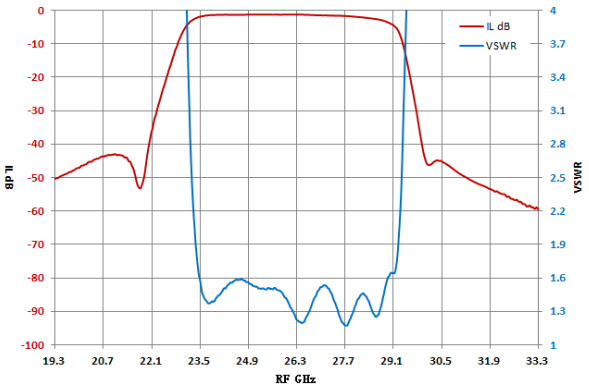


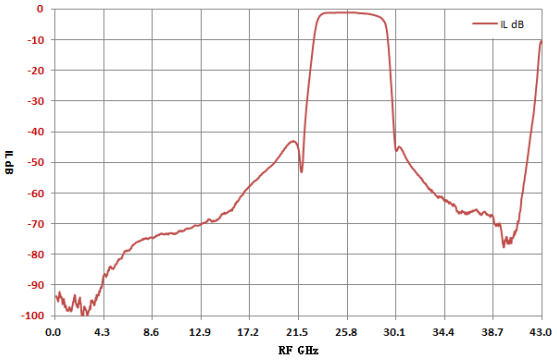
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



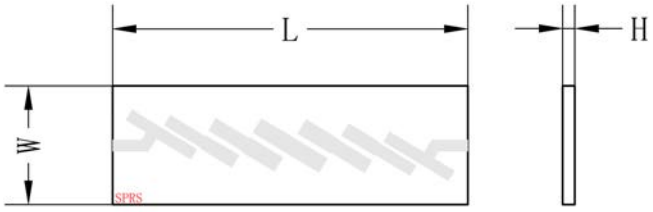
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	25.2	GHz
工作带宽	23.8-26.6	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	35@DC-22.1GHz	dBc
带外抑制	40@28.7-36.0GHz	dBc

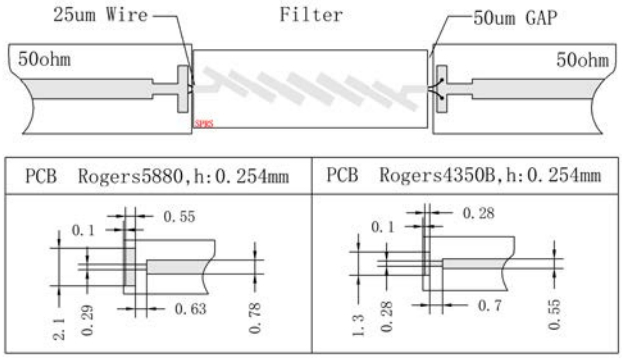
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



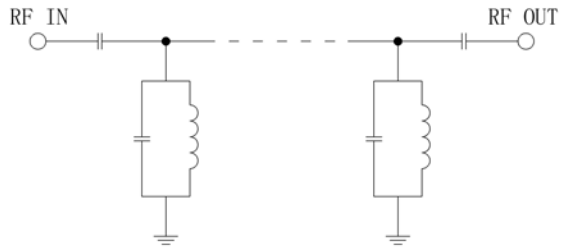
推荐装配图



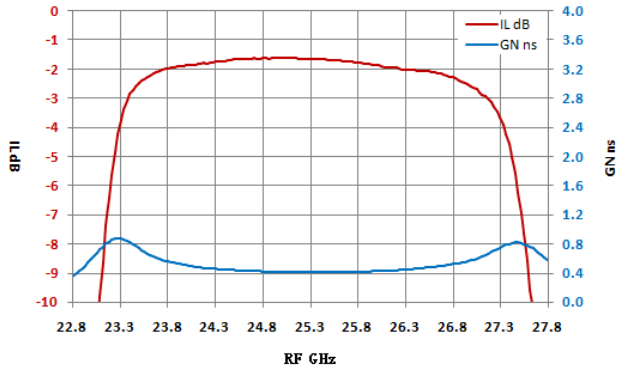
注意事项

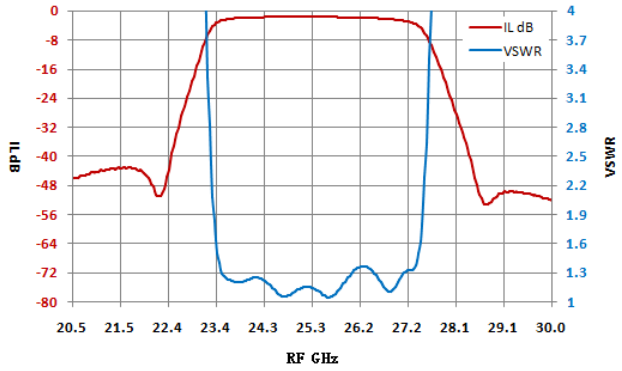
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

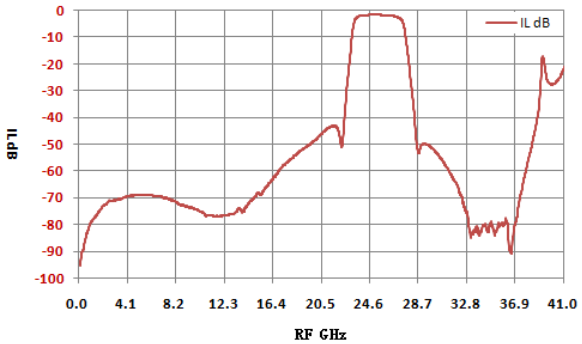
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

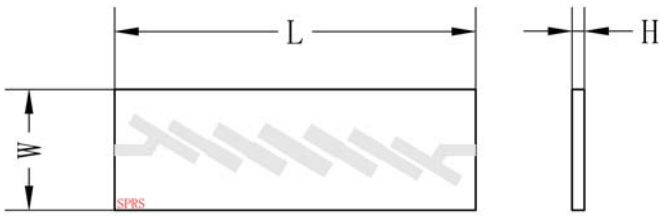
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	26.4	GHz
工作带宽	23.8-29.0	GHz
中心损耗	1.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	50@DC-21.3GHz	dBc
带外抑制	50@32.8-40.0GHz	dBc

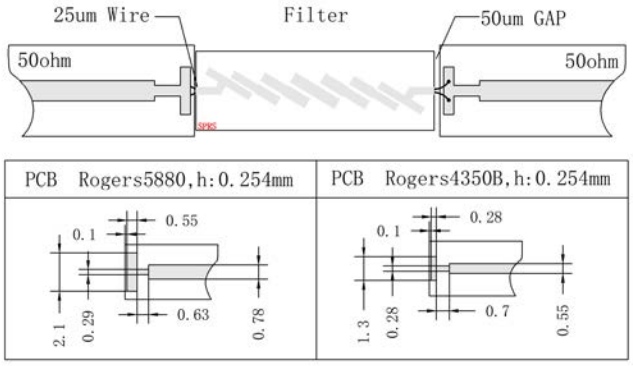
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：7.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

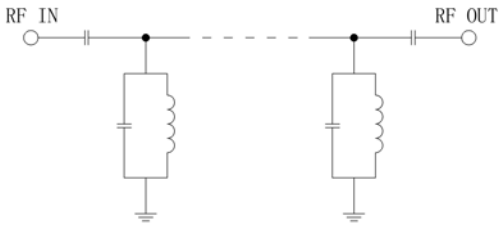
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

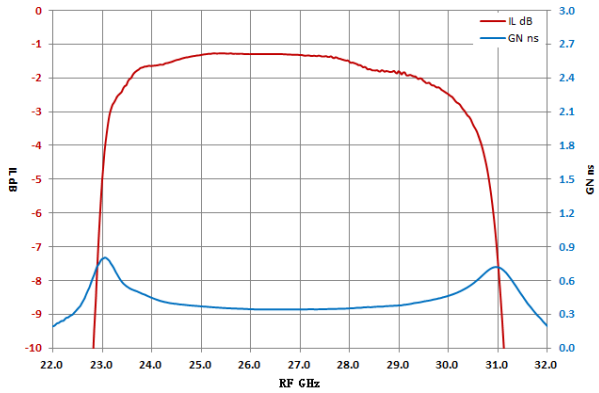
参考图

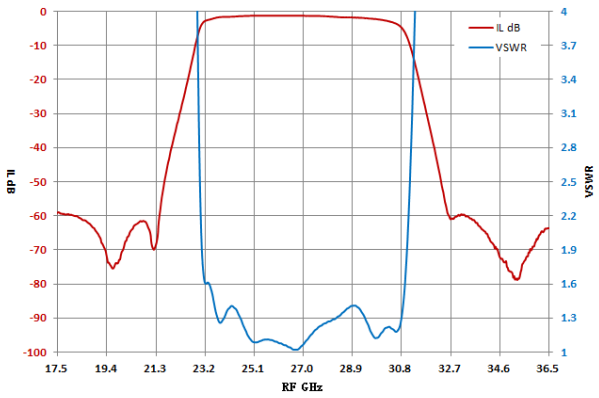


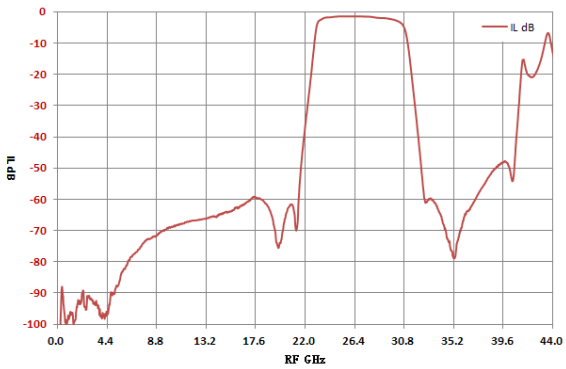
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

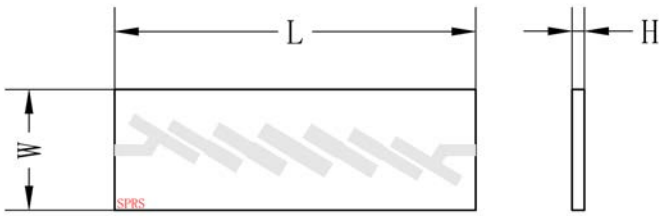
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	26.5	GHz
工作带宽	23.8-29.2	GHz
中心损耗	2.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	45@DC-21.2GHz	dBc
带外抑制	50@32.9-39.0GHz	dBc

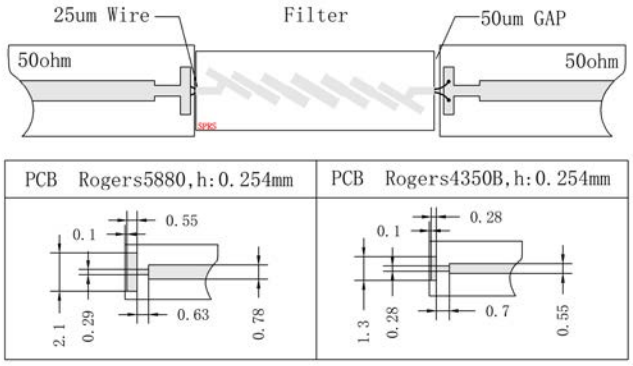
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

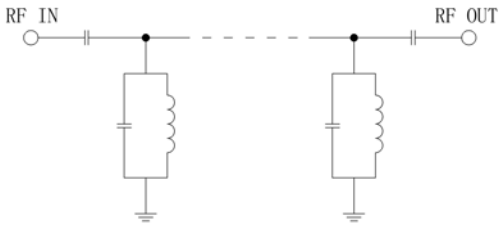
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

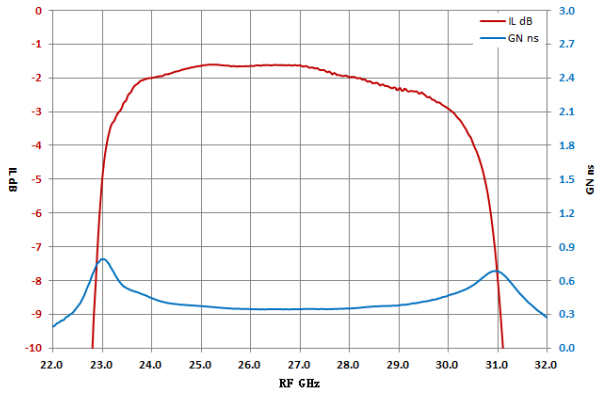
参考图

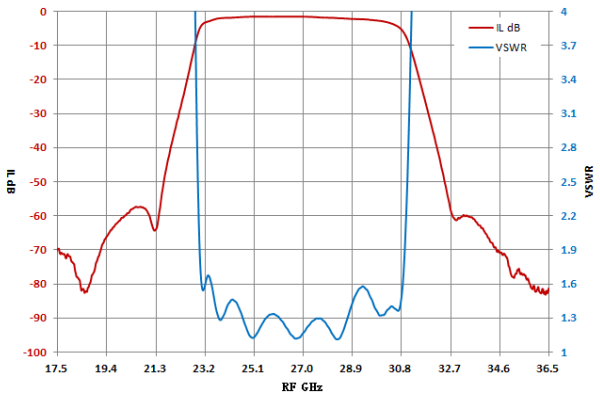


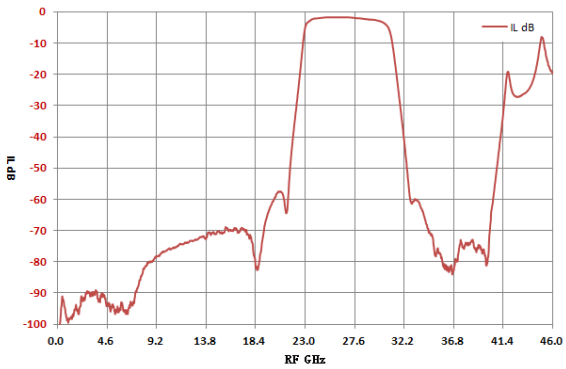
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

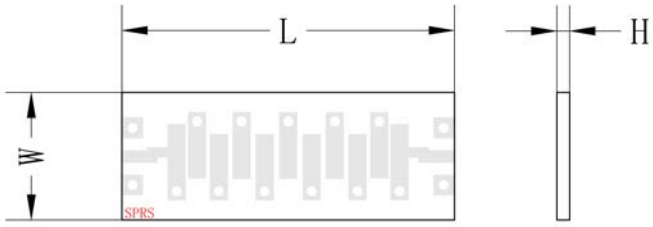
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	27.3	GHz
工作带宽	23.8-30.8	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-20.3GHz	dBc
带外抑制	40@34.7-37.0GHz	dBc

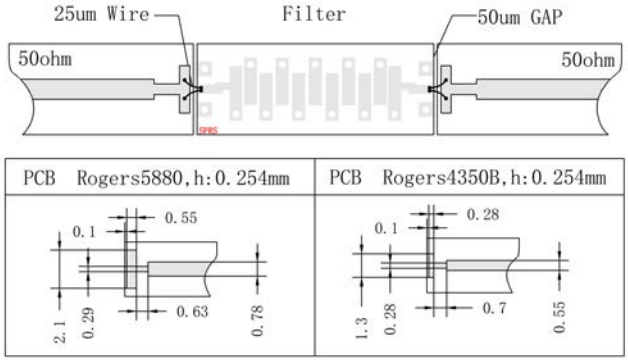
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



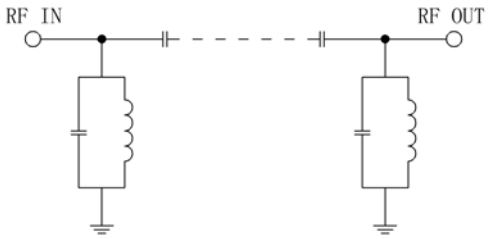
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

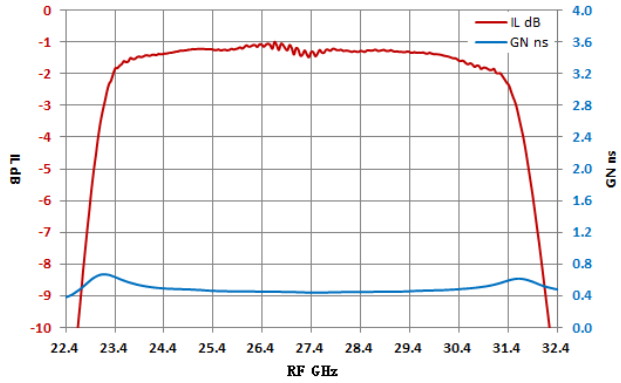
参考实物图

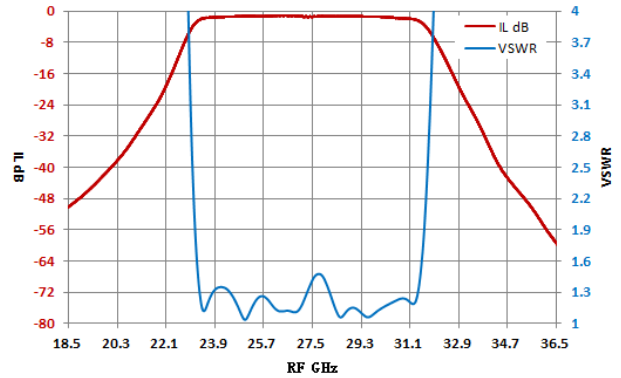


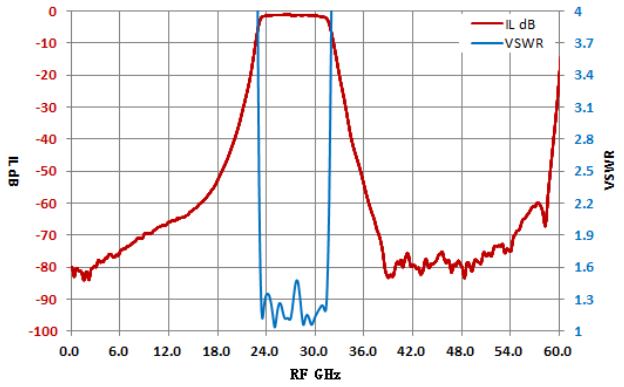
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



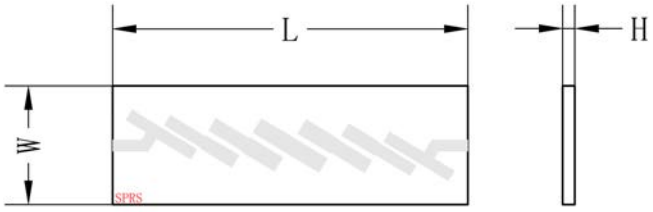
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	24.4	GHz
工作带宽	23.9-24.9	GHz
中心损耗	3.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-22.8GHz	dBc
带外抑制	40@26.0-39.0GHz	dBc

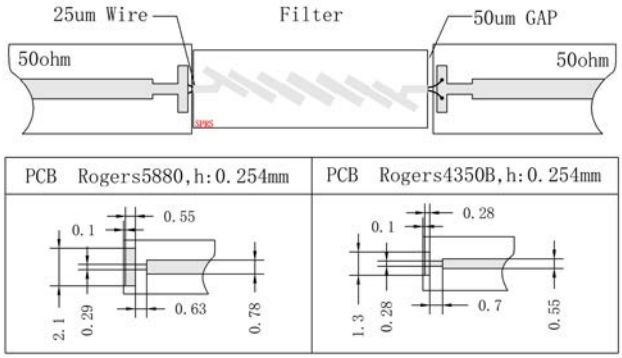
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：10.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



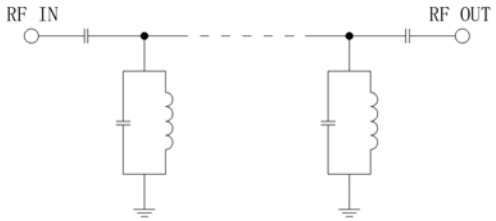
推荐装配图



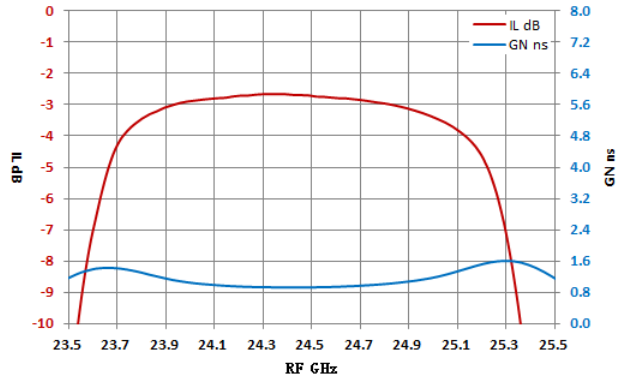
注意事项

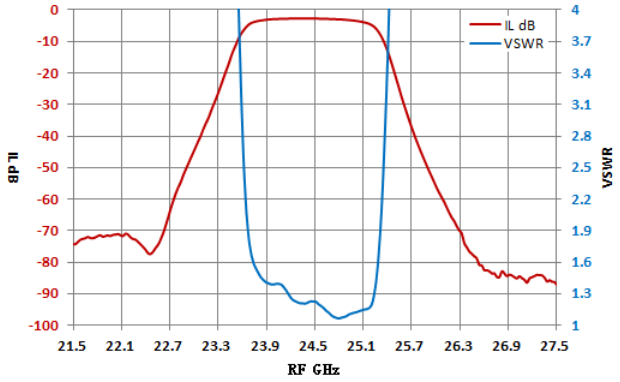
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

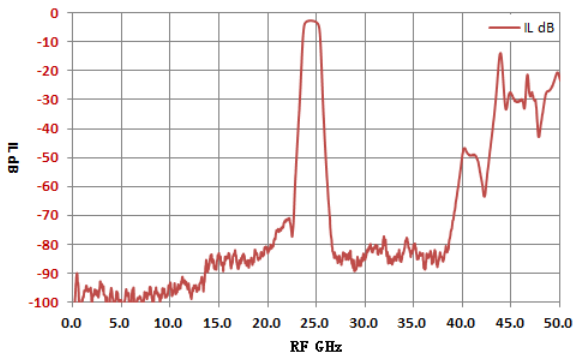
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



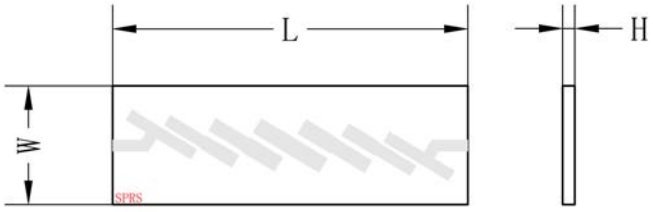
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	25.4	GHz
工作带宽	23.9-26.9	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-22.3GHz	dBc
带外抑制	40@29.0-34.0GHz	dBc

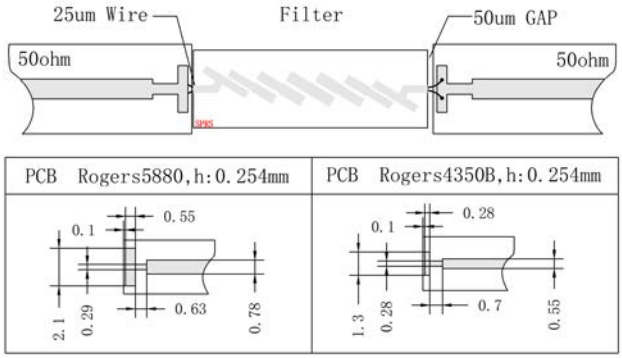
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



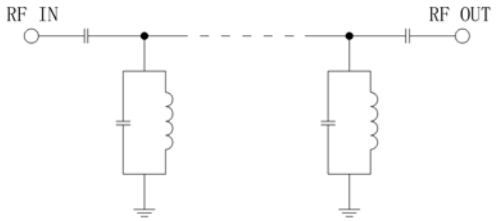
推荐装配图



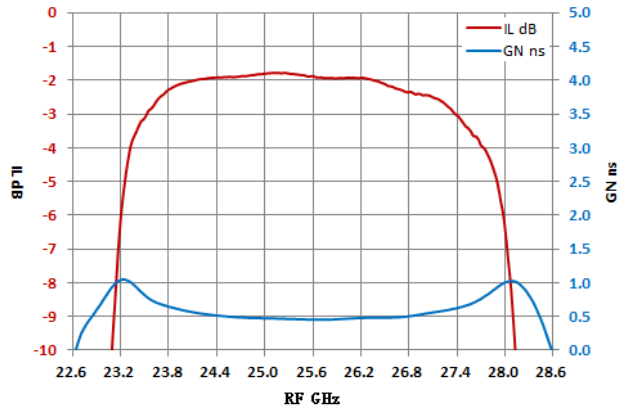
注意事项

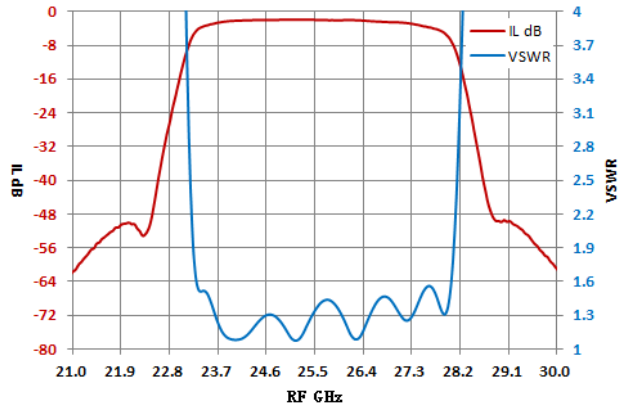
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

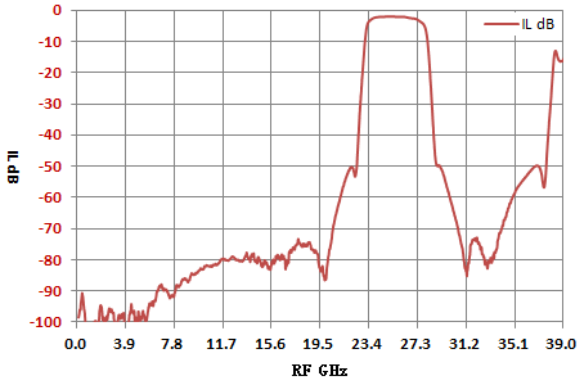
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



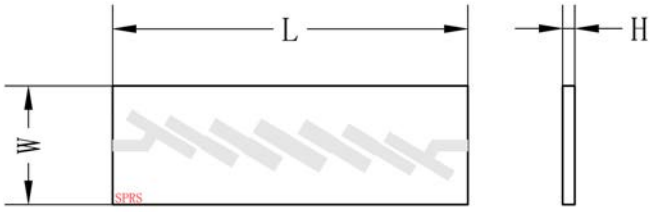
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	26.0	GHz
工作带宽	23.9-28.1	GHz
中心损耗	1.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-21.0GHz	dBc
带外抑制	40@31.5-40.0GHz	dBc

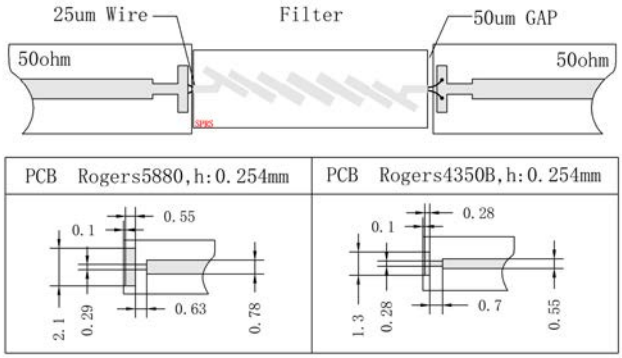
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



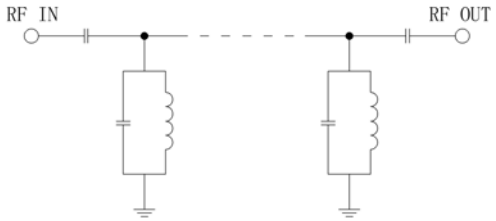
推荐装配图



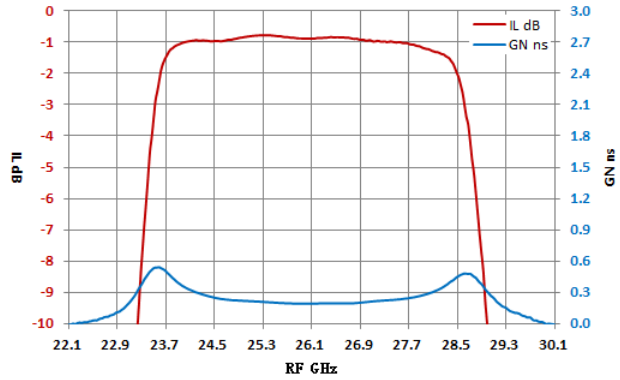
注意事项

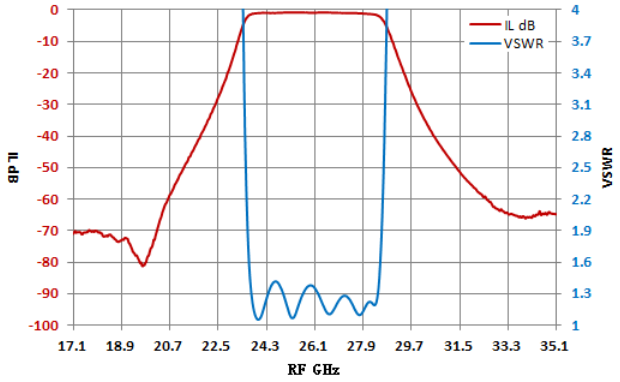
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

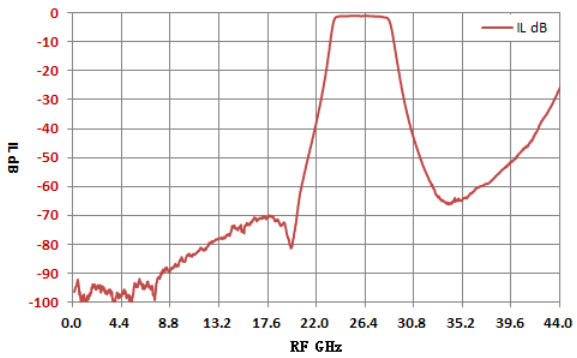
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



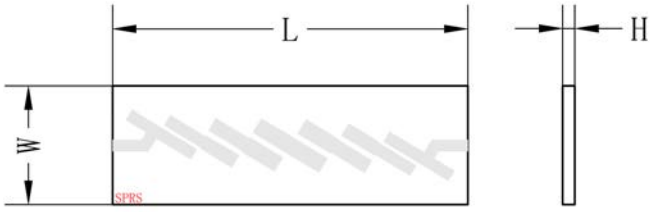
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	26.3	GHz
工作带宽	24.0-28.6	GHz
中心损耗	1.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-21.0GHz	dBc
带外抑制	40@32.4-37.0GHz	dBc

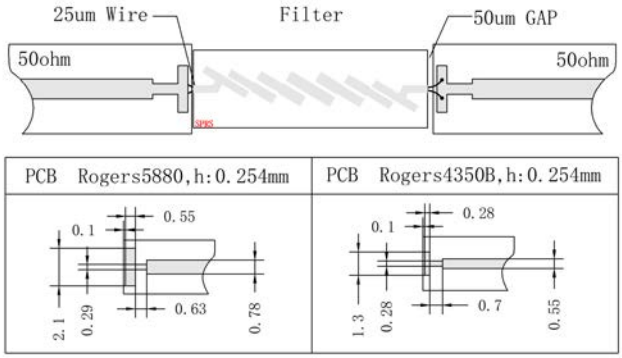
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



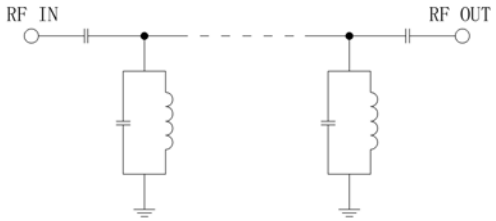
推荐装配图



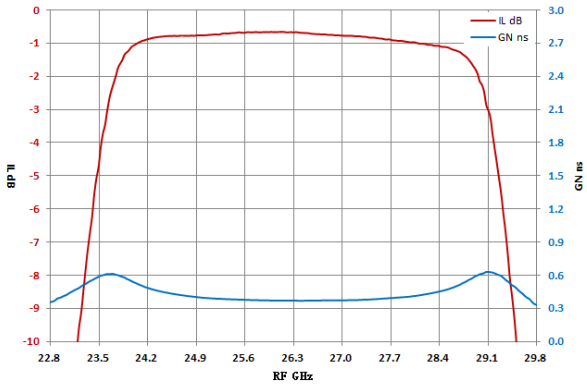
注意事项

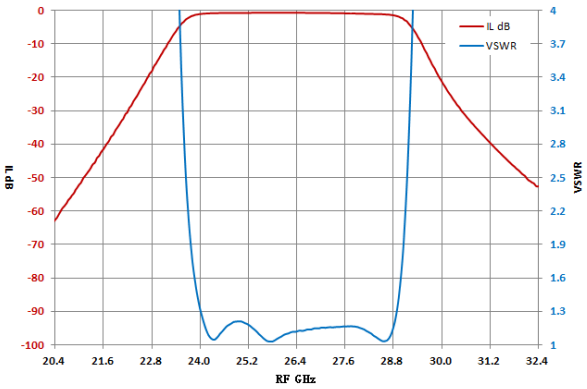
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

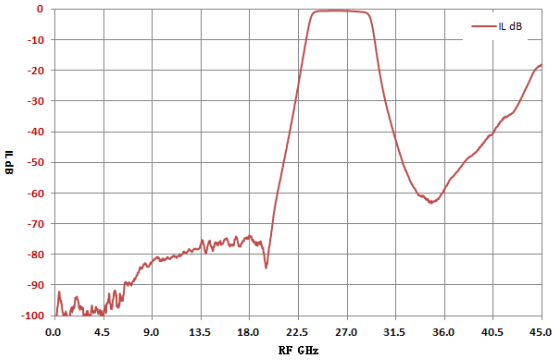
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

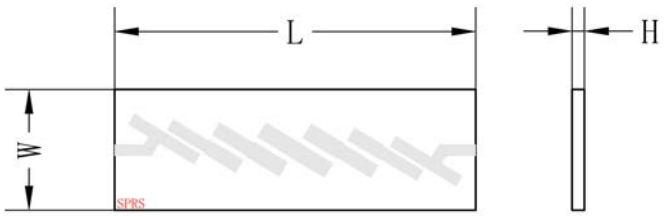
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	31.5	GHz
工作带宽	24.0-39.0	GHz
中心损耗	1.4	dB
带内波动	2.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-20.4GHz	dBc
带外抑制	40@43.8-50.0GHz	dBc

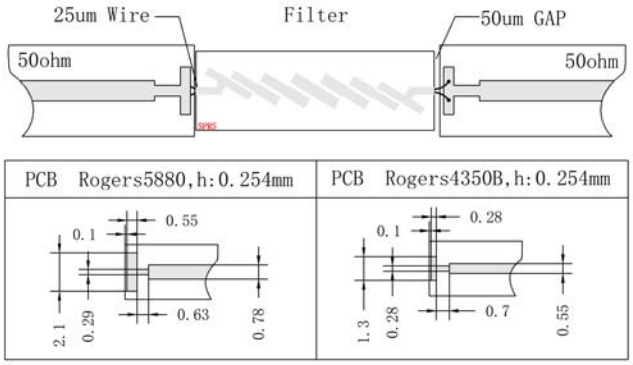
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：9.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

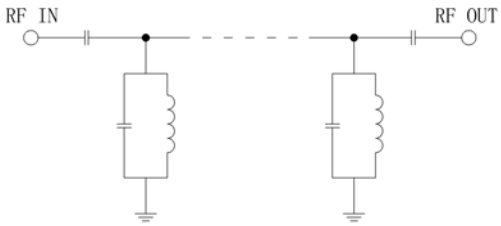
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

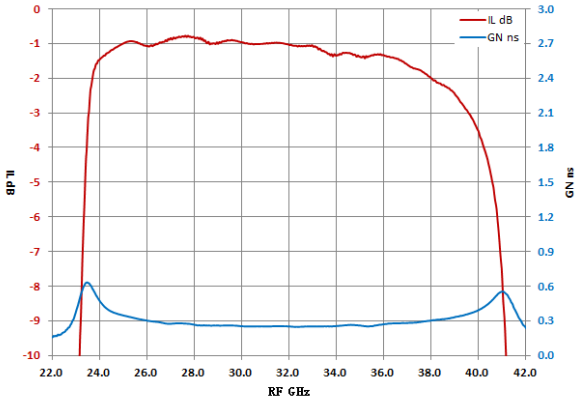
参考图

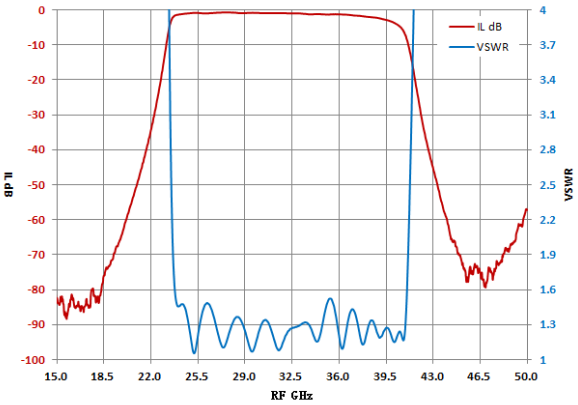


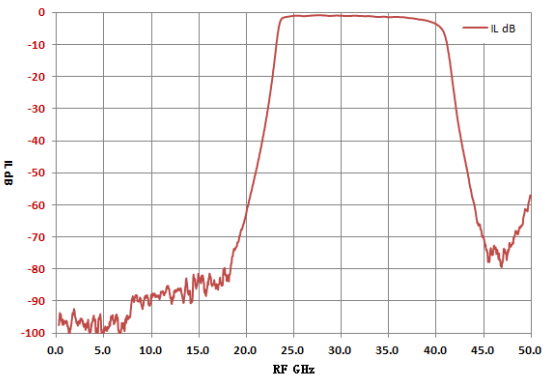
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



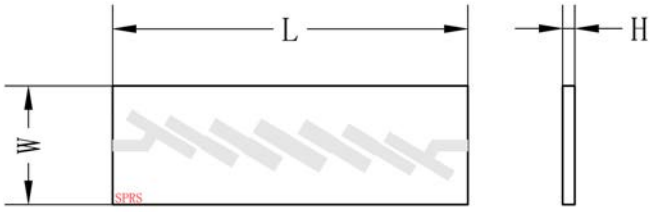
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	24.95	GHz
工作带宽	24.1-25.8	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-22.0GHz	dBc
带外抑制	40@27.7-40.0GHz	dBc

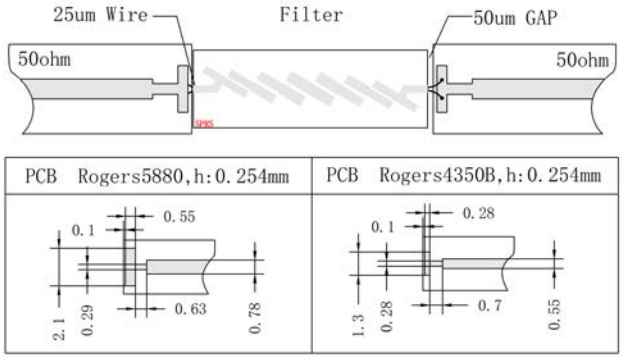
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



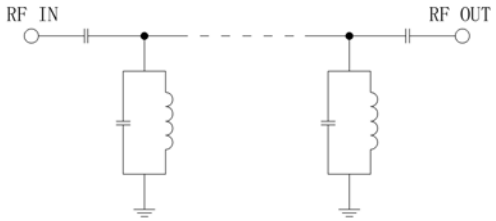
推荐装配图



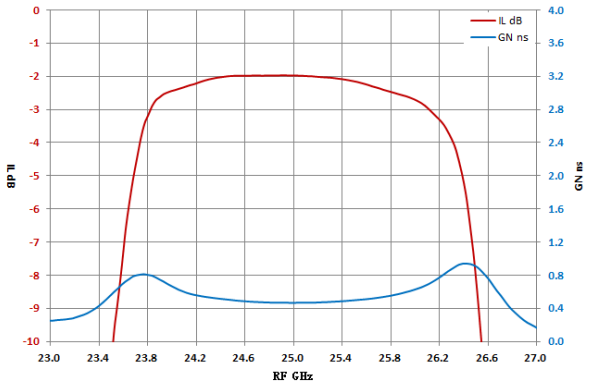
注意事项

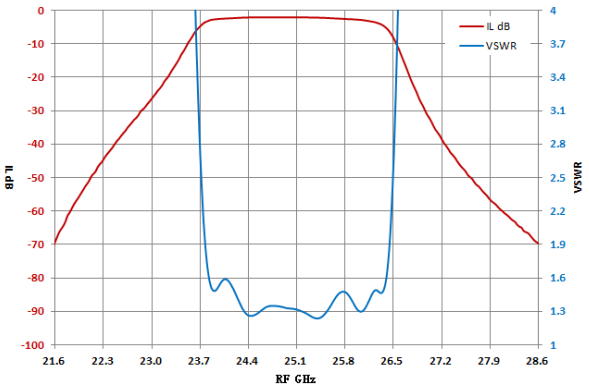
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

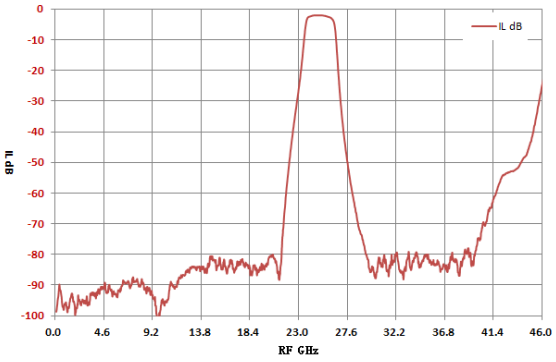
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

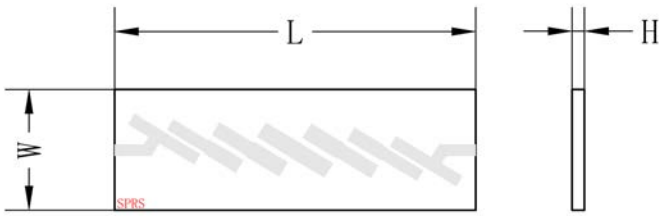
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	25.1	GHz
工作带宽	24.1-26.1	GHz
中心损耗	2.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	35@DC-23.1GHz	dBc
带外抑制	35@27.3-36.0GHz	dBc

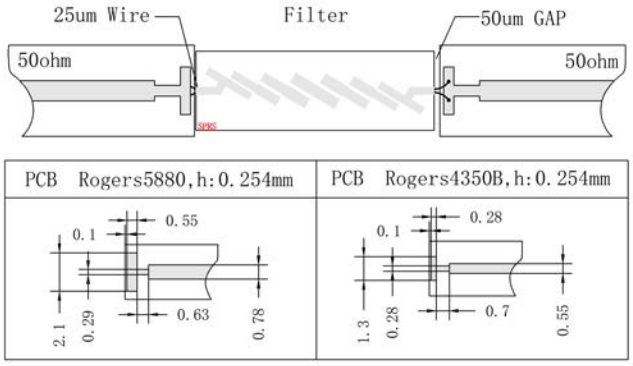
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：5.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

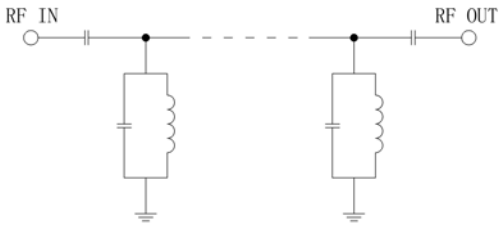
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

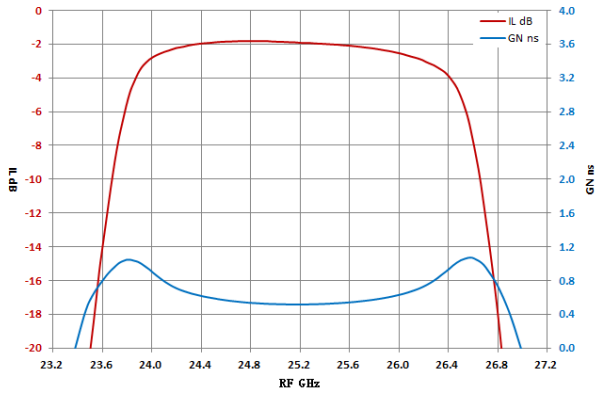
参考图

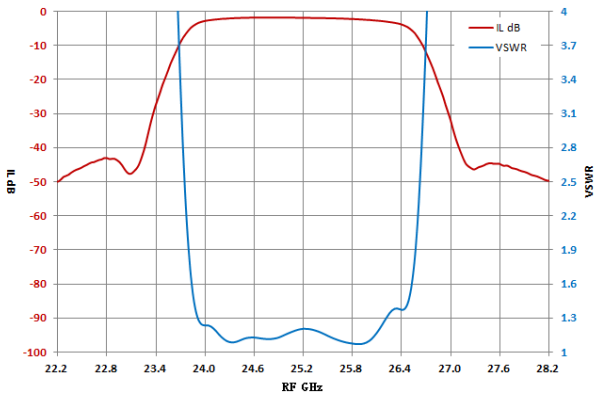


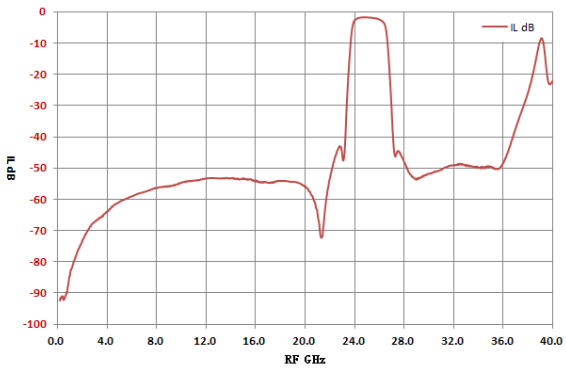
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

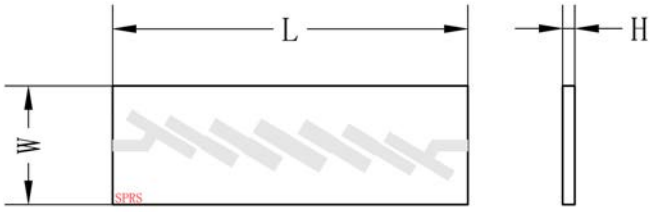
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	25.7	GHz
工作带宽	24.1-27.3	GHz
中心损耗	1.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-22.5GHz	dBc
带外抑制	40@29.1-40.0GHz	dBc

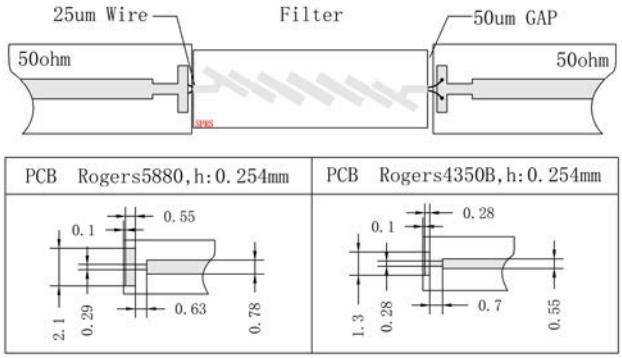
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



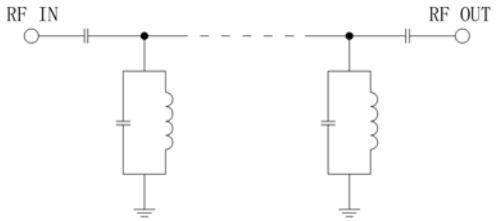
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

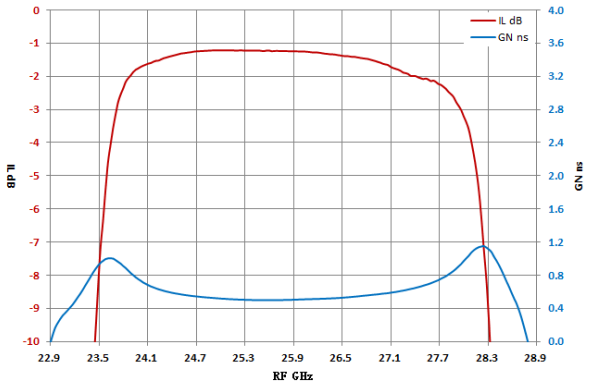
参考实物图

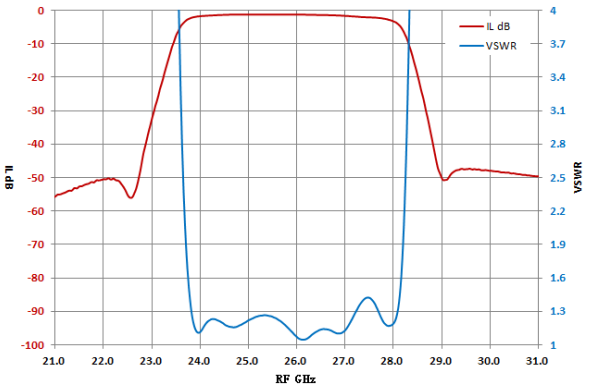


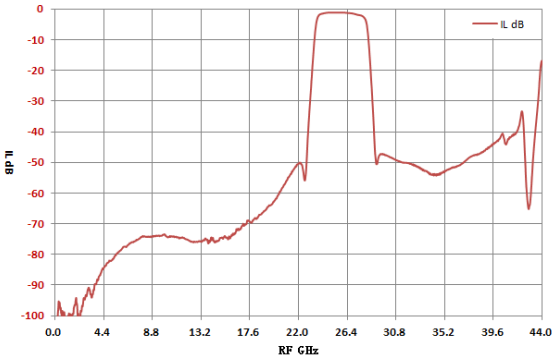
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

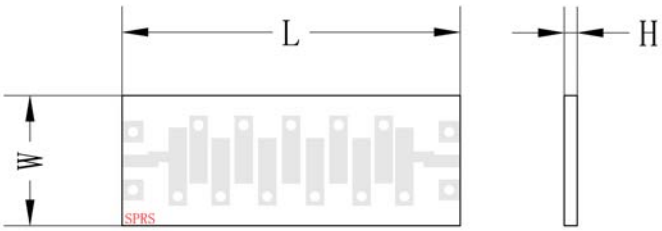
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	29.0	GHz
工作带宽	24.2-33.8	GHz
中心损耗	1.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	35@DC-21.2GHz	dBc
带外抑制	40@40.0-49.0GHz	dBc

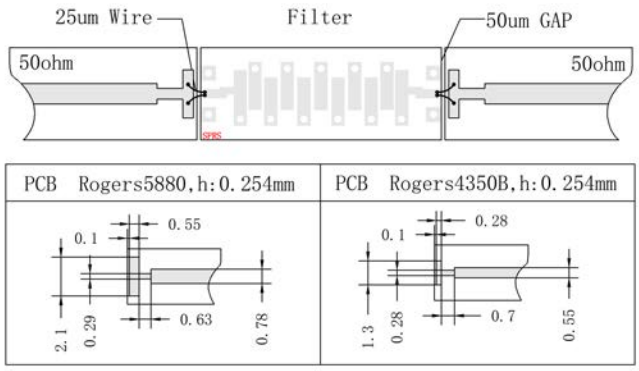
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：3.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.74mm,端口可互换;

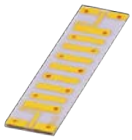
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

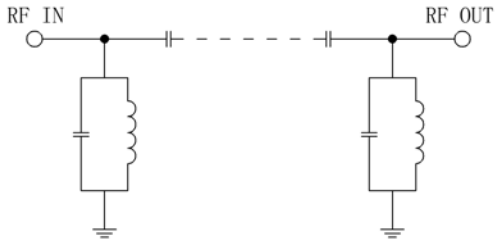
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

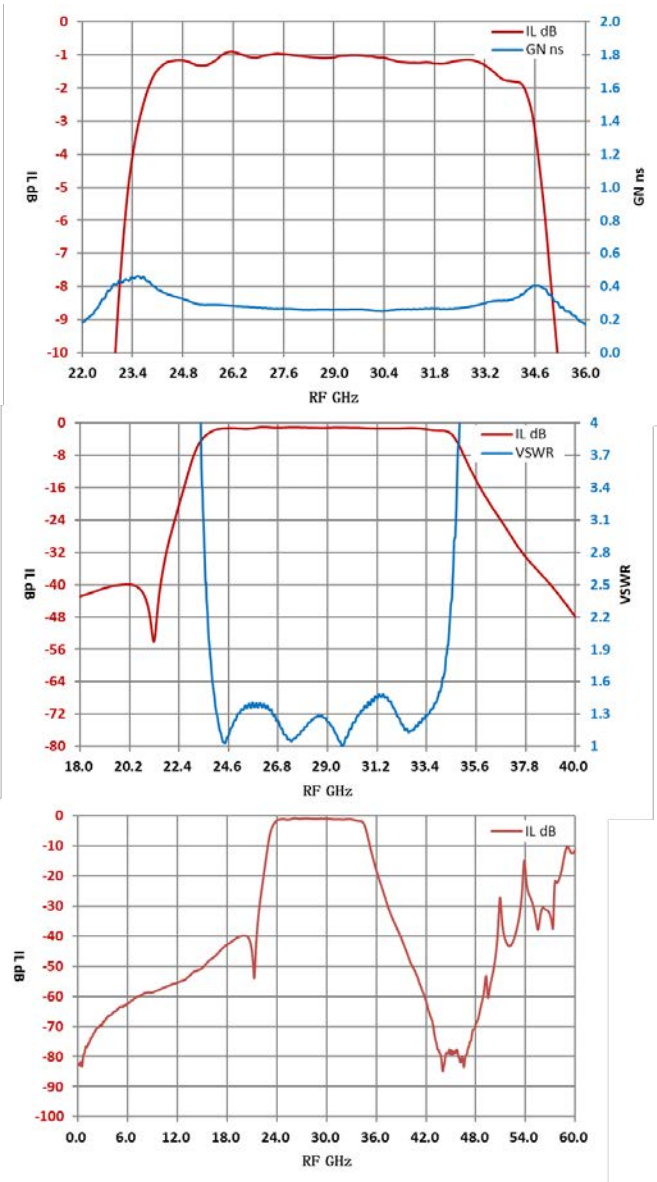
参考图



原理图



典型曲线



产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

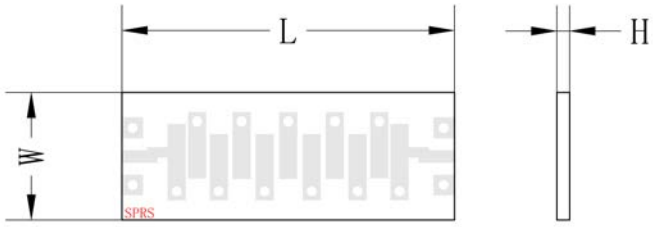
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	26.7	GHz
工作带宽	24.3-29.1	GHz
中心损耗	2.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-21.0GHz	dBc
带外抑制	40@32.2-37.0GHz	dBc

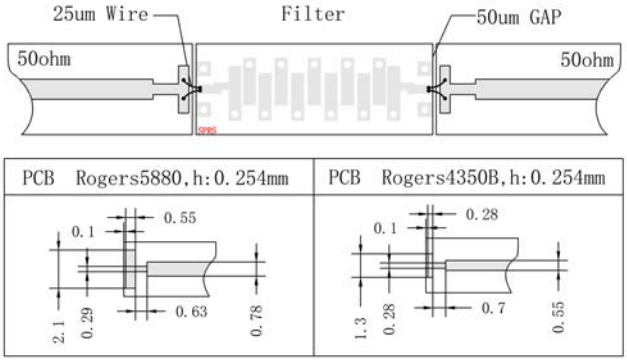
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



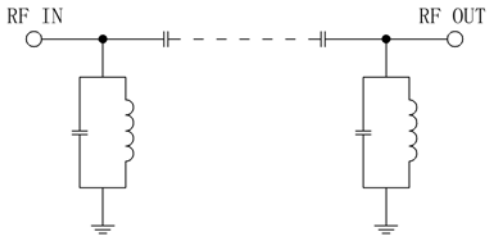
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

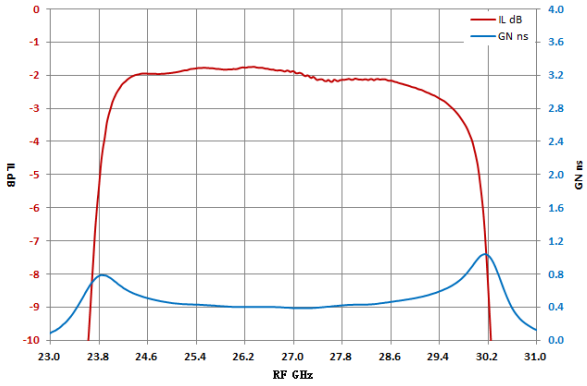
参考实物图

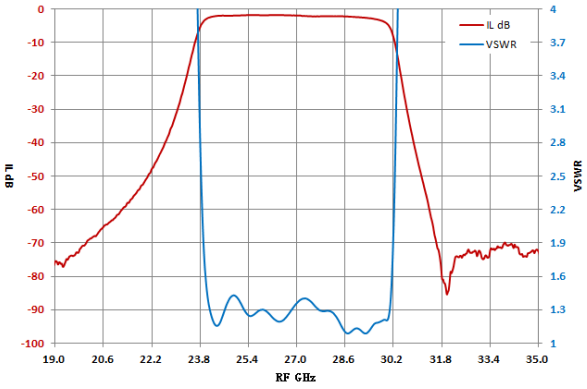


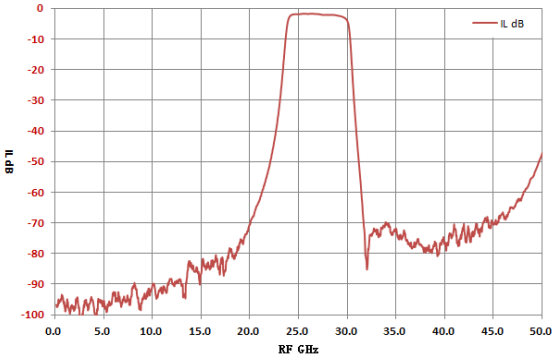
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



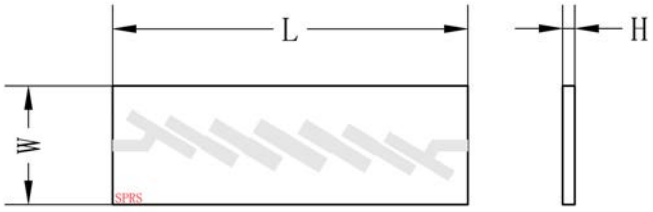
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	29.85	GHz
工作带宽	24.5-35.2	GHz
中心损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-18.5GHz	dBc
带外抑制	40@42.5-56.0GHz	dBc

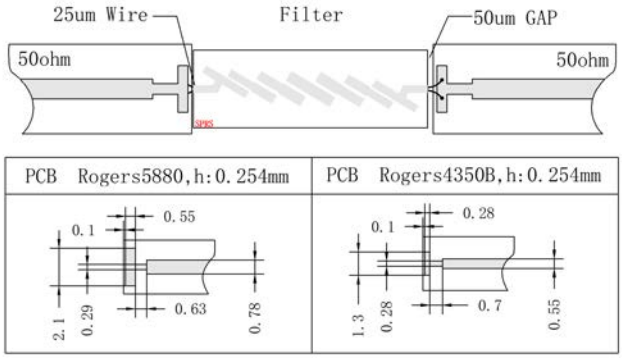
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



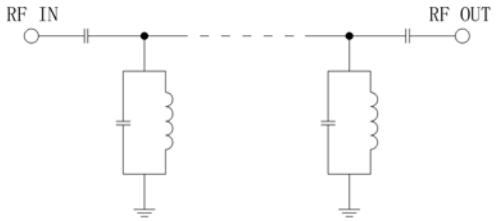
推荐装配图



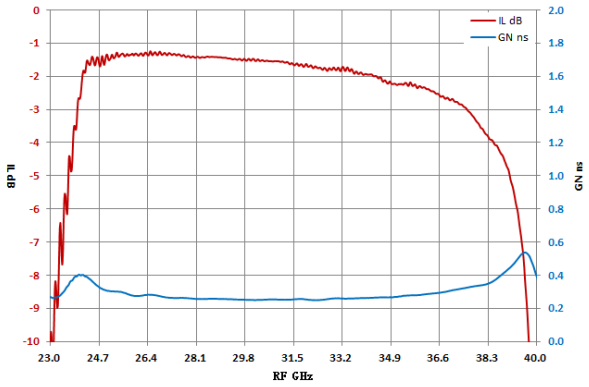
注意事项

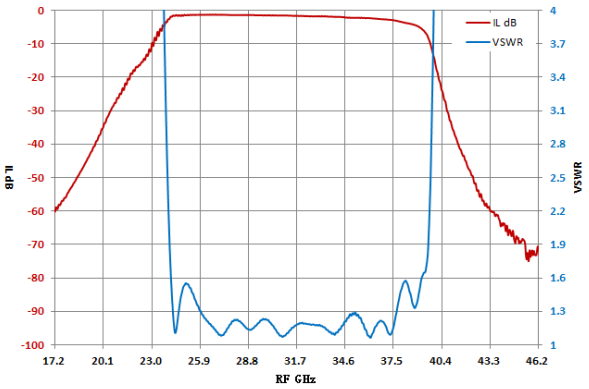
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

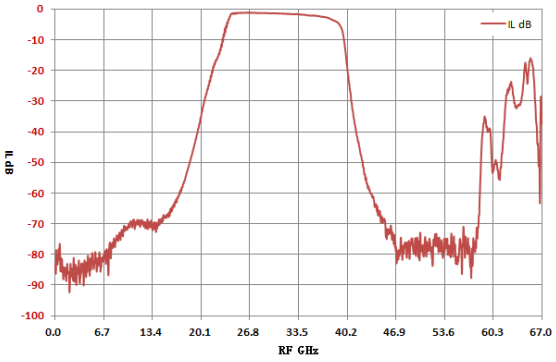
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



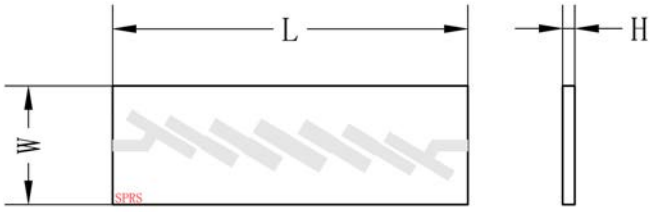
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	28.6	GHz
工作带宽	24.6-32.6	GHz
中心损耗	1.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-22.2GHz	dBc
带外抑制	40@36.4-45.0GHz	dBc

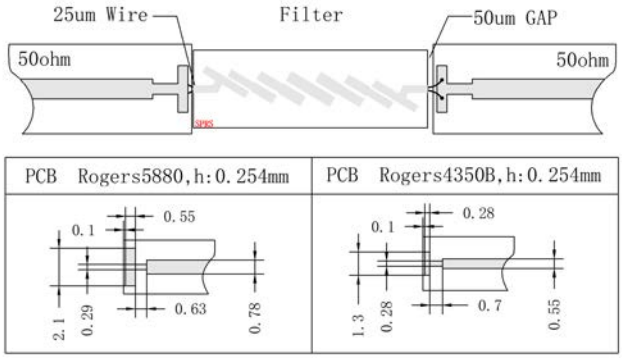
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



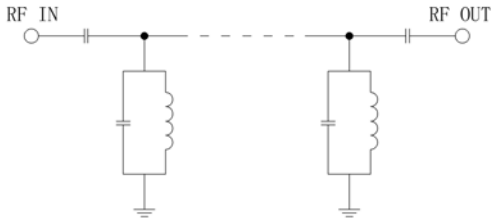
推荐装配图



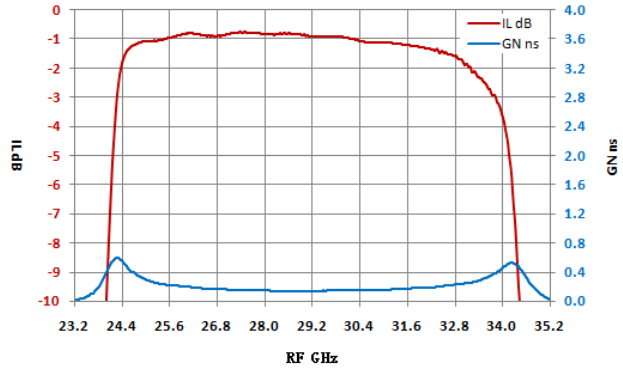
注意事项

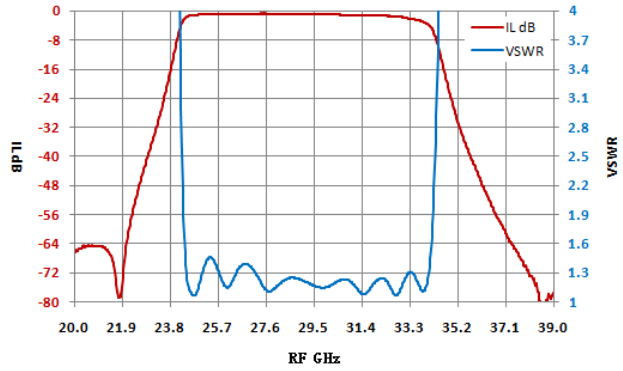
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

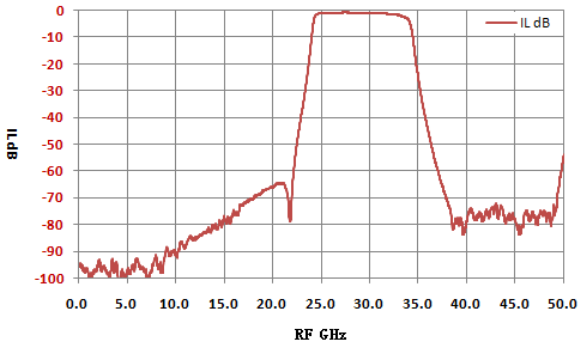
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



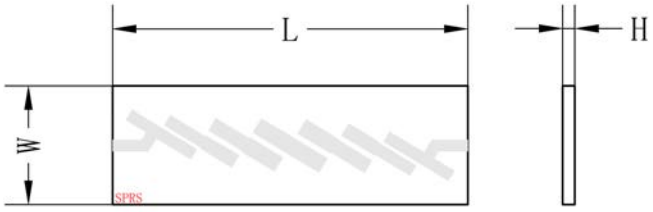
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	28.8	GHz
工作带宽	24.6-33.0	GHz
中心损耗	1.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-20.2GHz	dBc
带外抑制	40@37.0-50.0GHz	dBc

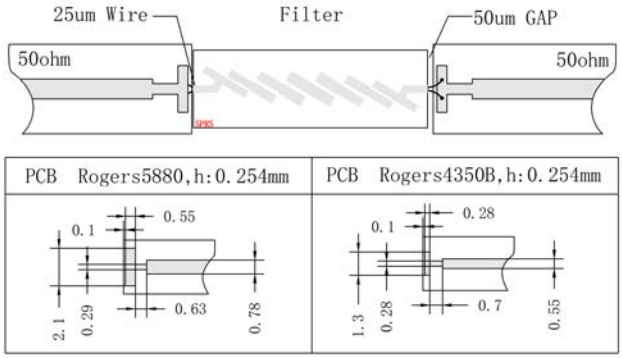
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



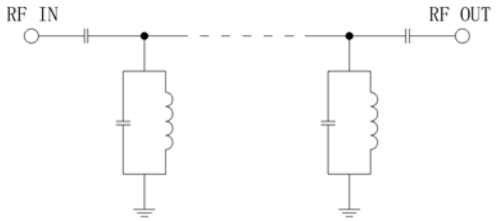
推荐装配图



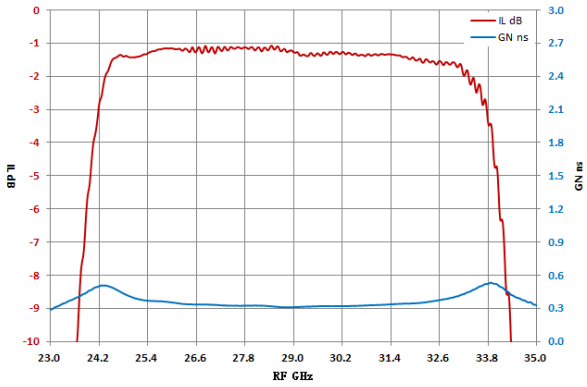
注意事项

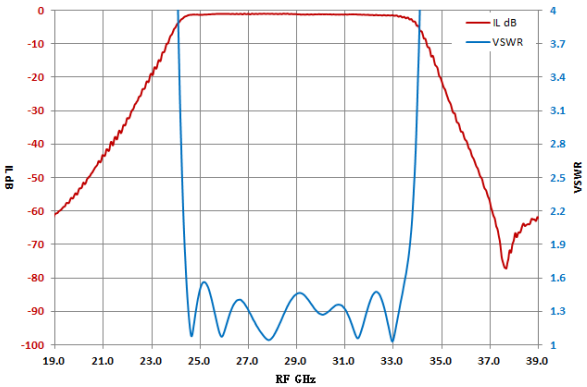
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

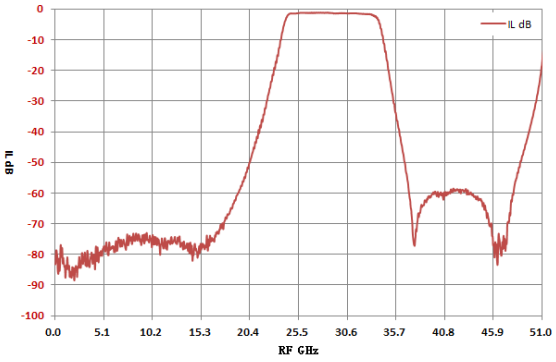
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



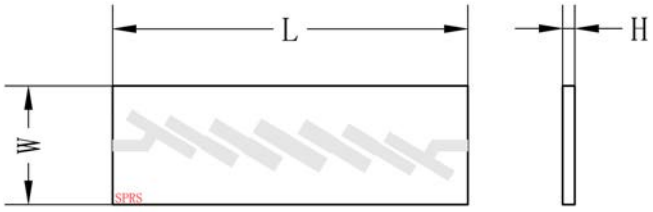
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	25.9	GHz
工作带宽	24.8-27.0	GHz
中心损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	35@DC-23.1GHz	dBc
带外抑制	40@28.6-33.0GHz	dBc

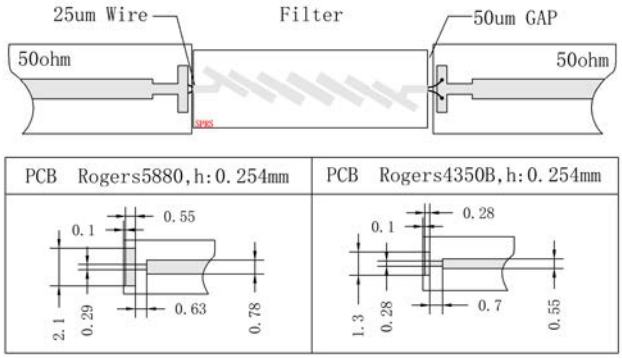
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：4.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



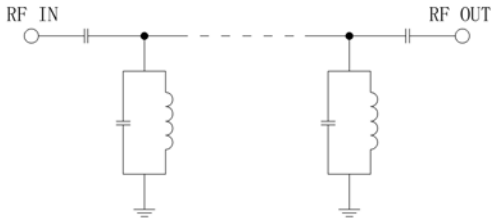
推荐装配图



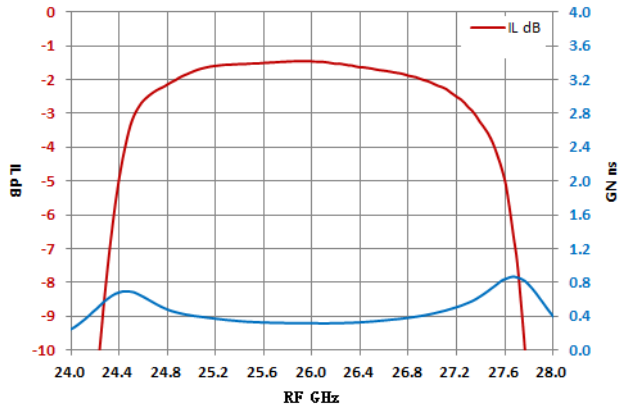
注意事项

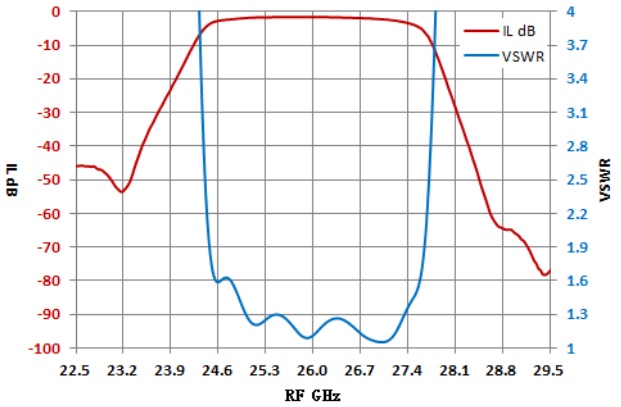
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

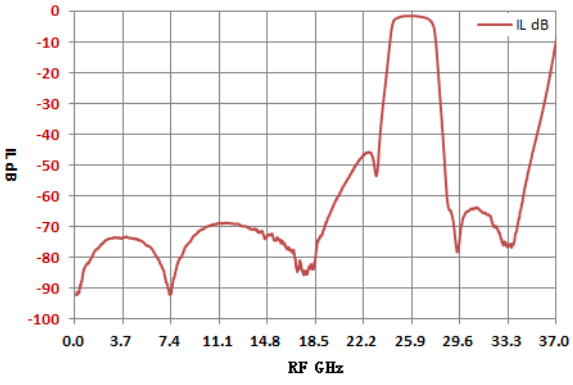
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

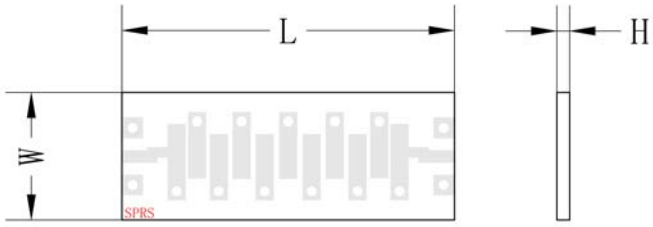
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	27.0	GHz
工作带宽	24.8-29.2	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-22.3GHz	dBc
带外抑制	40@31.9-35.0GHz	dBc

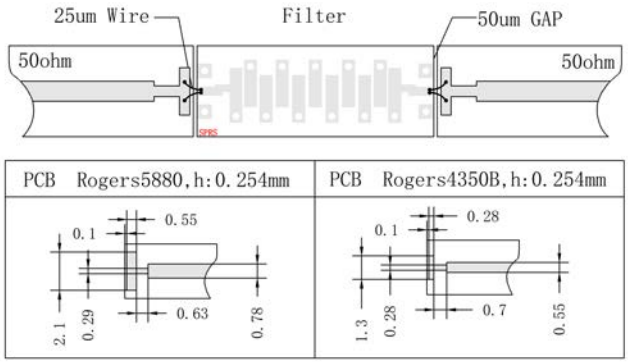
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.2，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



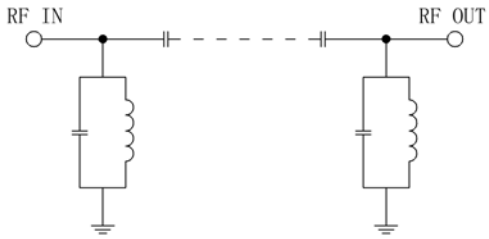
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

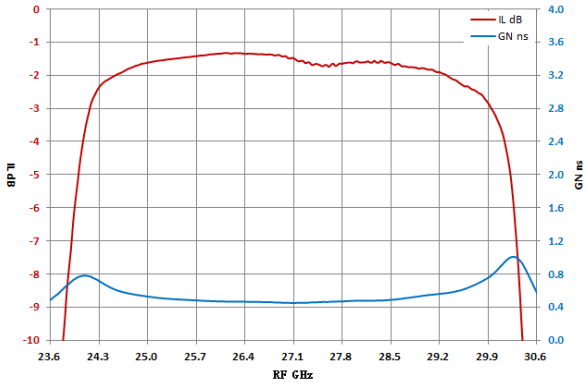
参考实物图

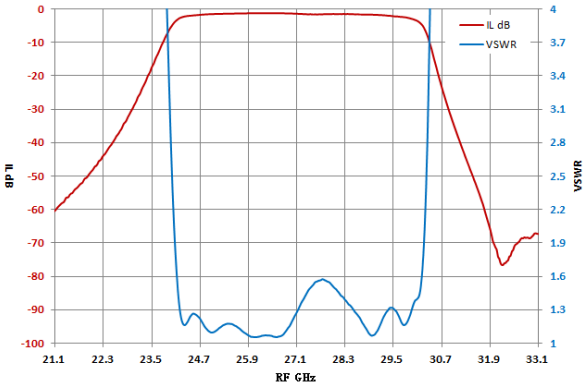


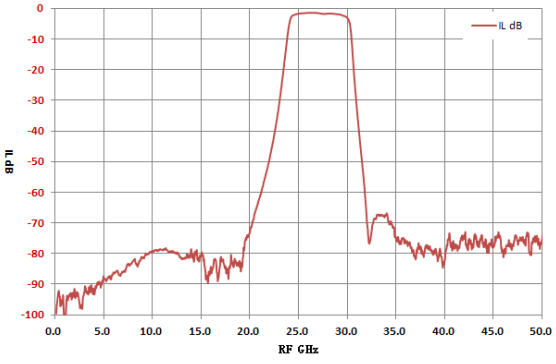
原理图



典型曲线







产品特点

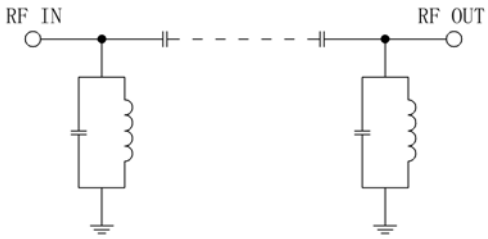
高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



技术要求

项目	参数	单位
中心频率	27.6	GHz
工作带宽	25.0-30.2	GHz
中心损耗	2.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-22.8GHz	dBc
带外抑制	40@32.8-49.0GHz	dBc

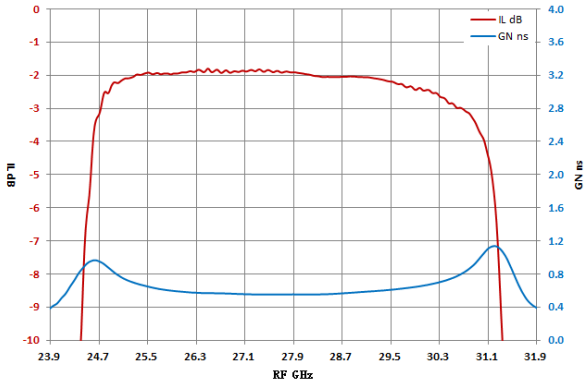
原理图

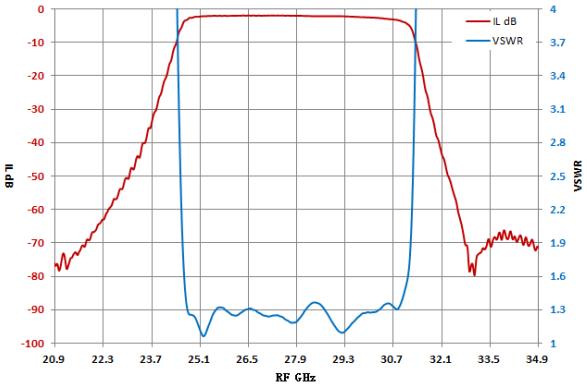


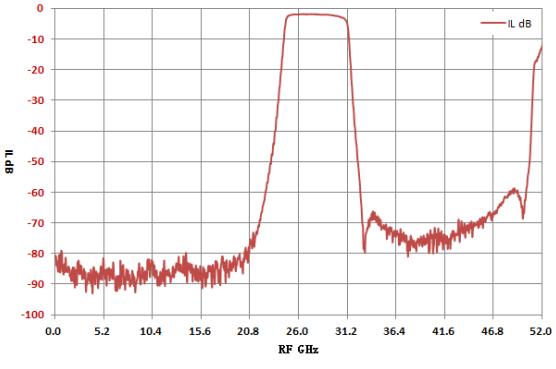
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

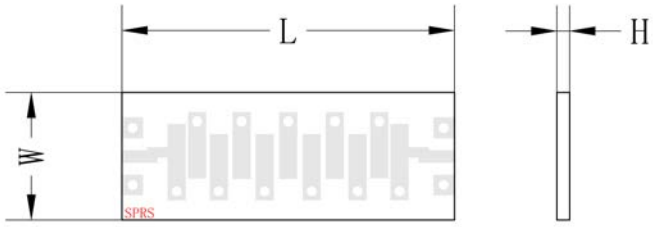
典型曲线



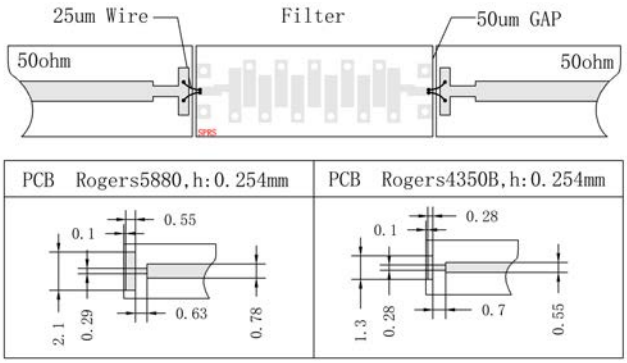




外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

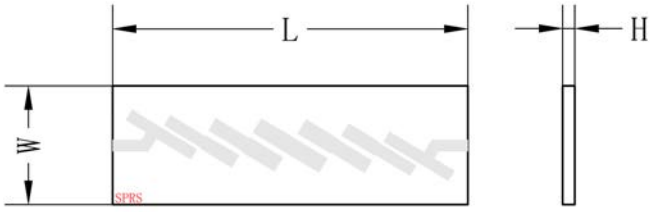
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	27.8	GHz
工作带宽	25.0-30.6	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-21.9GHz	dBc
带外抑制	40@34.0-46.0.0GHz	dBc

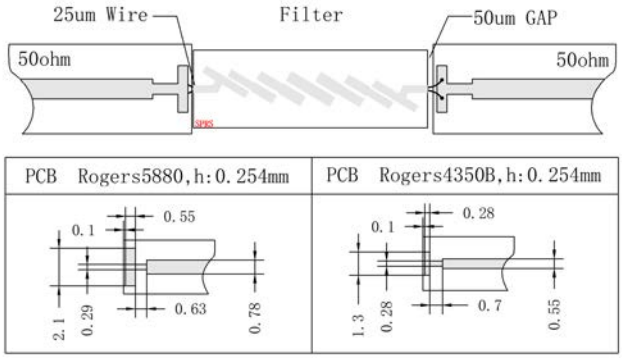
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



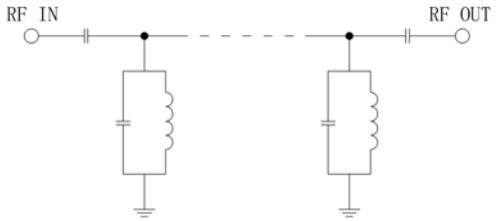
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

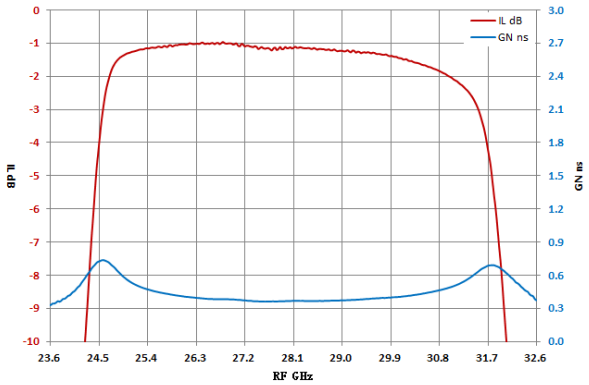
参考实物图

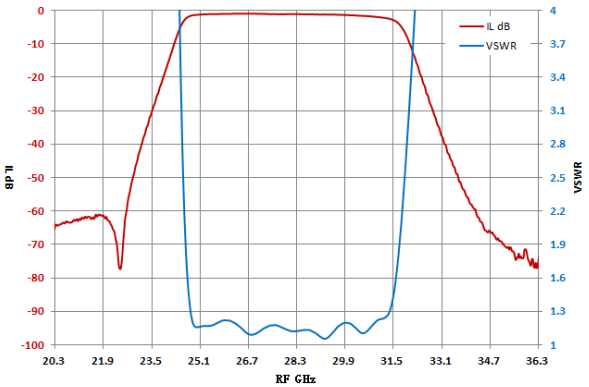


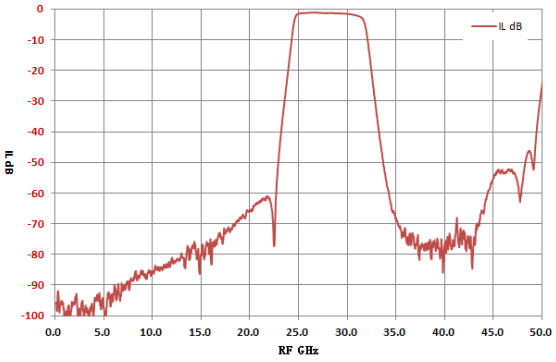
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

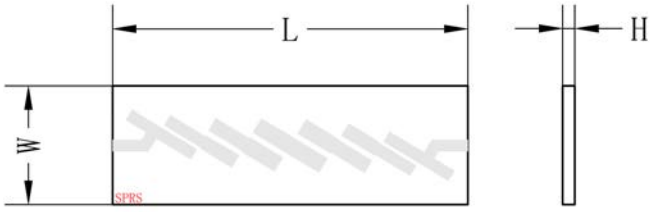
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	25.5	GHz
工作带宽	25.1-25.9	GHz
中心损耗	2.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC23.9GHz	dBc
带外抑制	40@27.1-34.0GHz	dBc

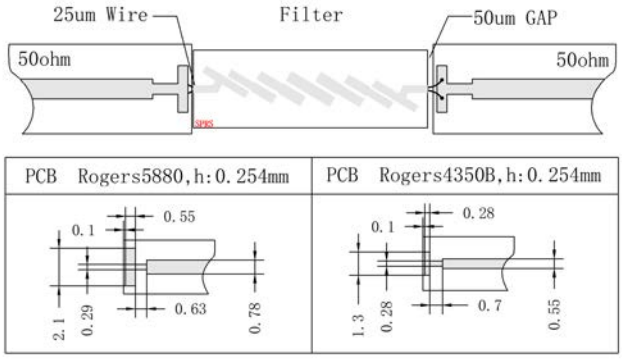
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.9，W：3.75，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



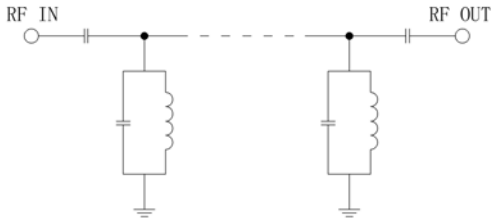
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

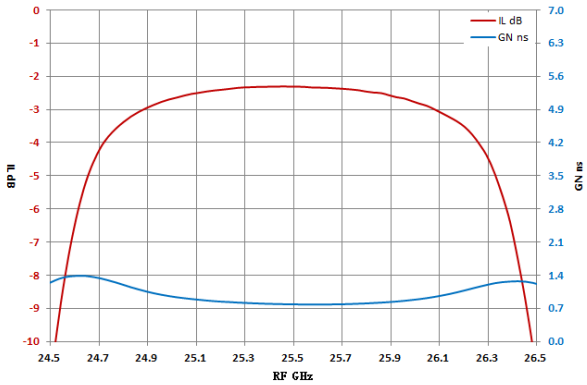
参考实物图

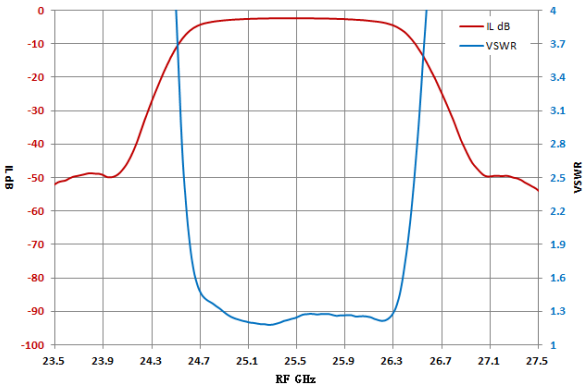


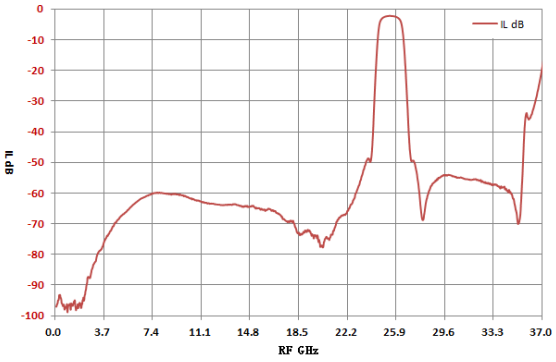
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

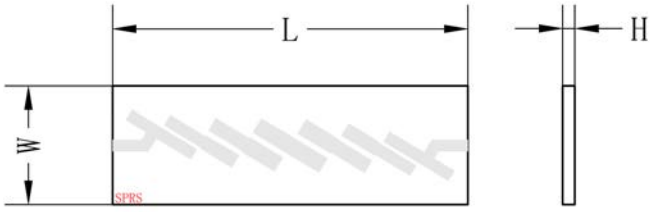
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	29.4	GHz
工作带宽	25.1-33.7	GHz
中心损耗	1.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-20.0GHz	dBc
带外抑制	40@39.8-44.0GHz	dBc

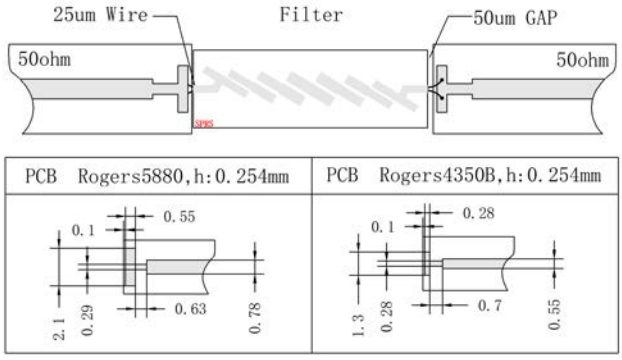
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



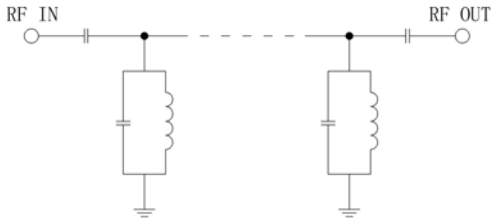
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

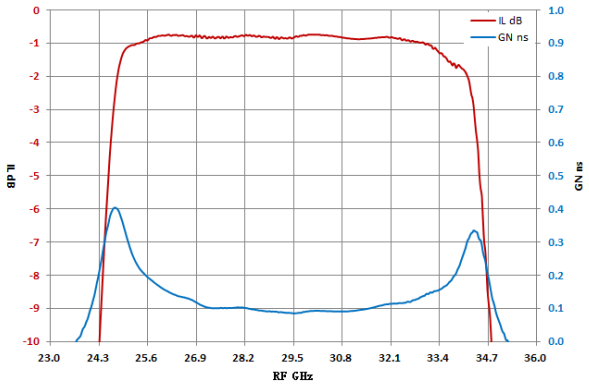
参考实物图

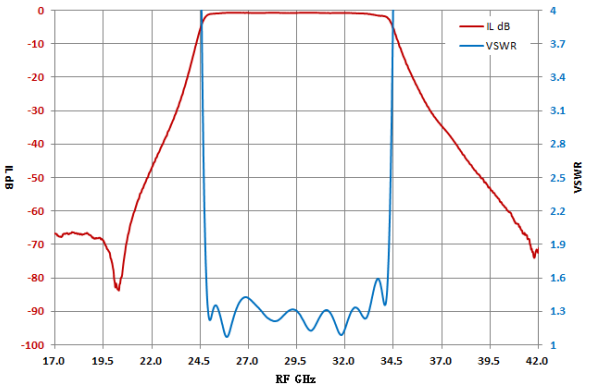


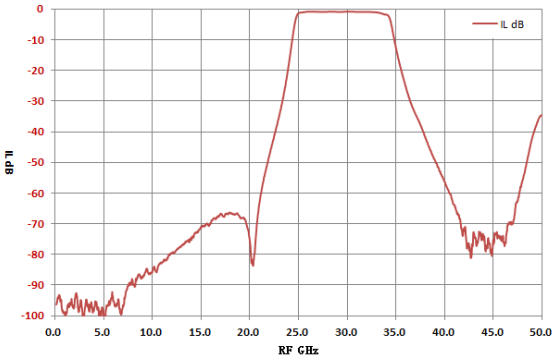
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



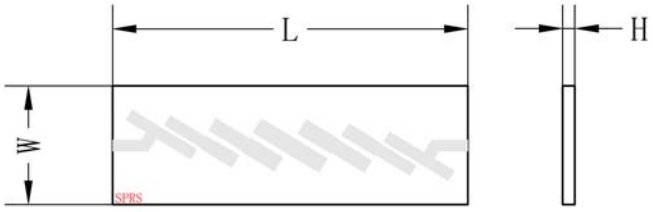
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	25.6	GHz
工作带宽	25.2-26.0	GHz
中心损耗	3.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-24.1GHz	dBc
带外抑制	40@27.1-42.0GHz	dBc

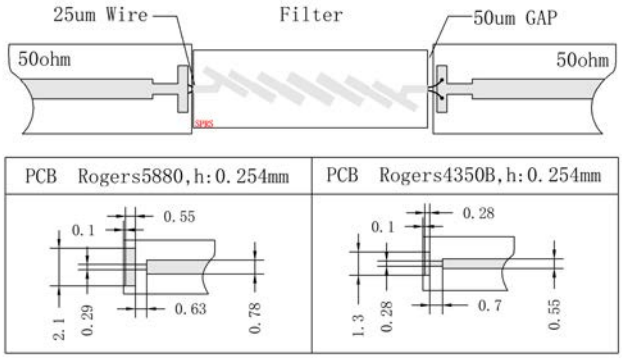
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：10.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



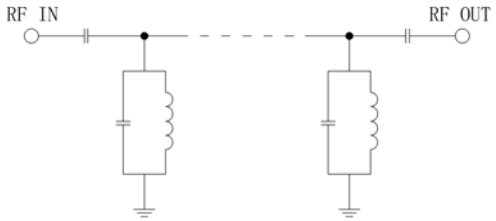
推荐装配图



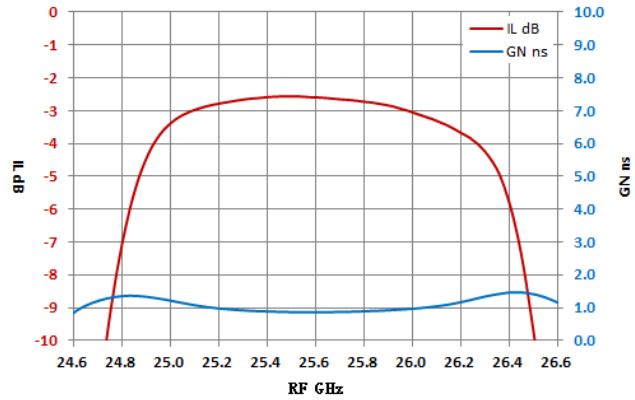
注意事项

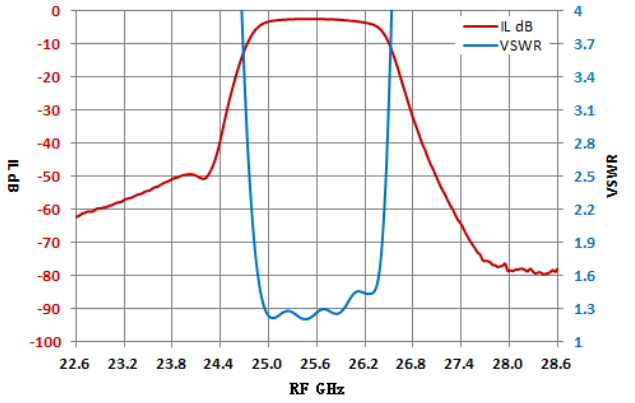
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.25mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

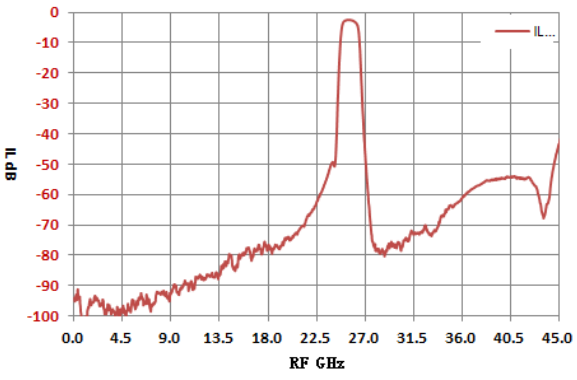
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

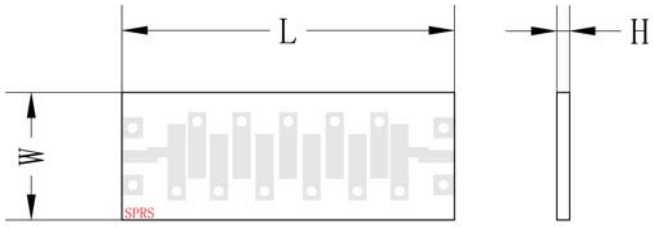
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	27.6	GHz
工作带宽	25.2-30.0	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-22.0GHz	dBc
带外抑制	40@33.2-58.0GHz	dBc

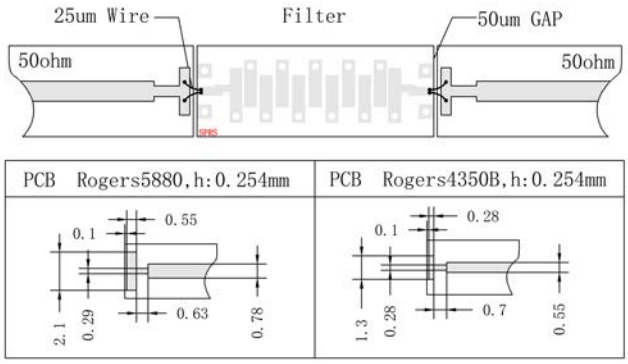
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.2，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



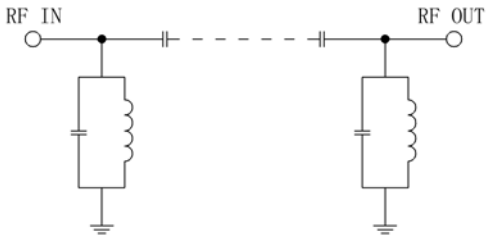
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

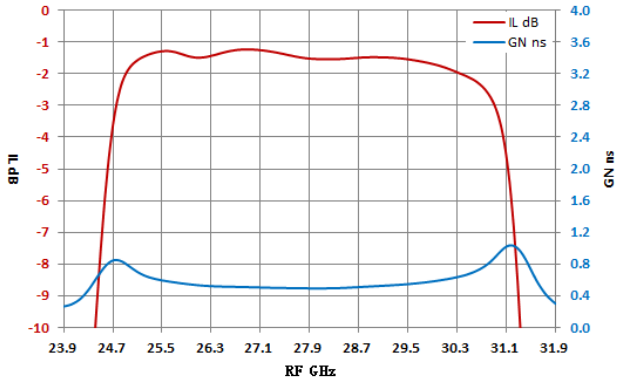
参考实物图

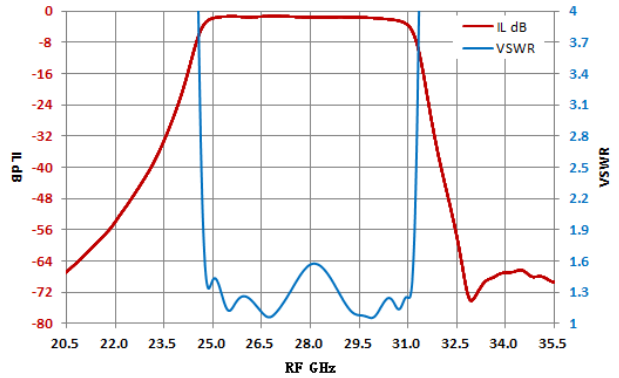


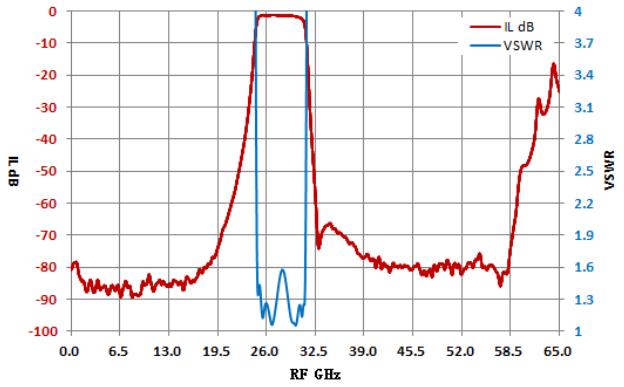
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



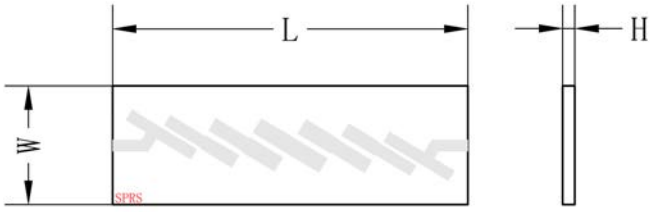
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	29.0	GHz
工作带宽	25.2-32.8	GHz
中心损耗	0.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-22.2GHz	dBc
带外抑制	40@37.5-47.0GHz	dBc

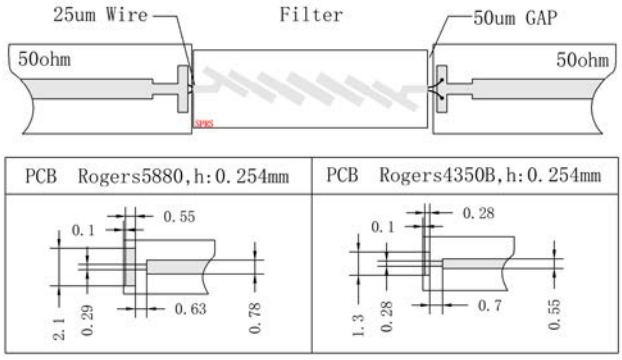
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



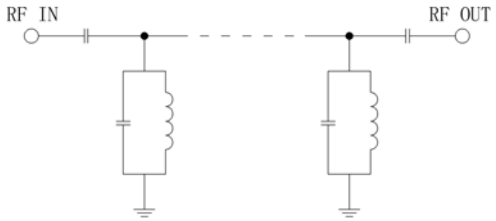
推荐装配图



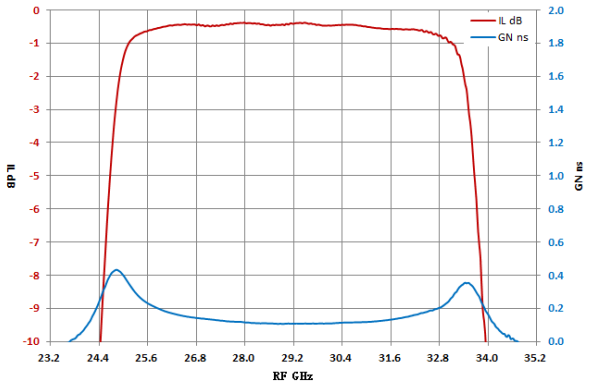
注意事项

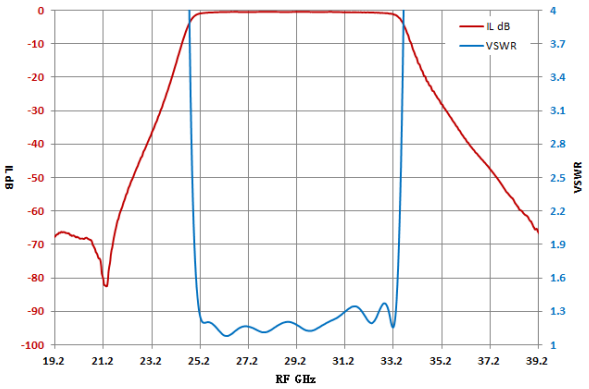
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

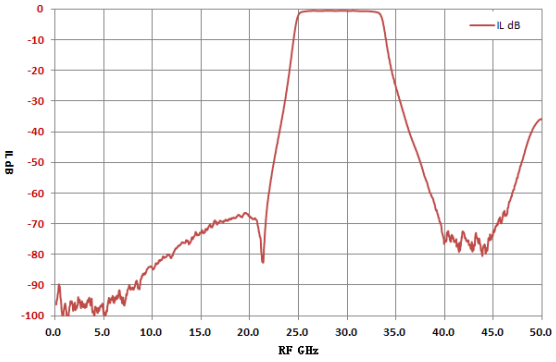
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



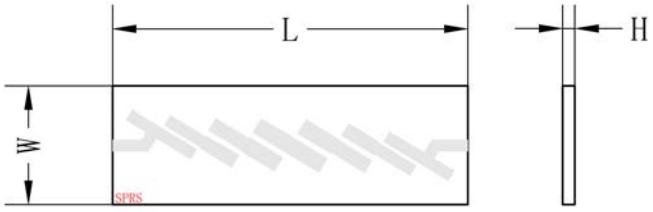
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	25.8	GHz
工作带宽	25.4-26.2	GHz
中心损耗	3.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-24.2GHz	dBc
带外抑制	40@27.6-37.0GHz	dBc

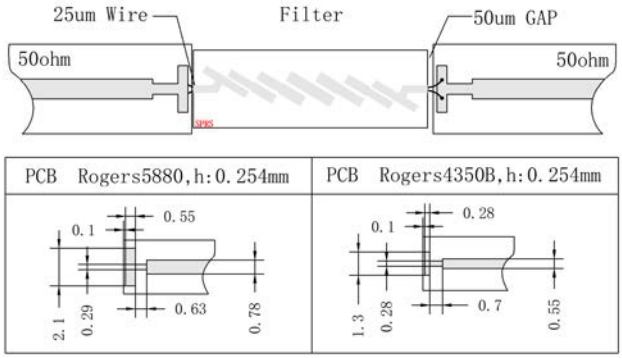
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



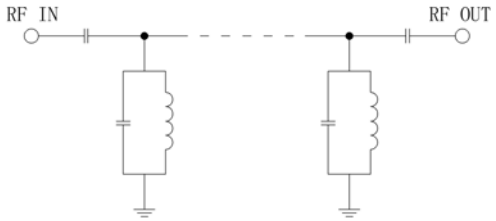
推荐装配图



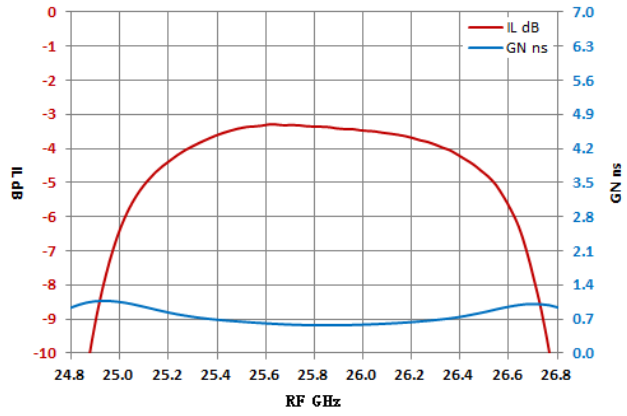
注意事项

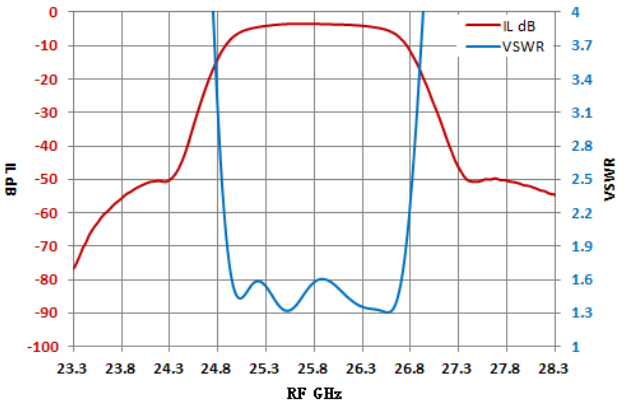
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

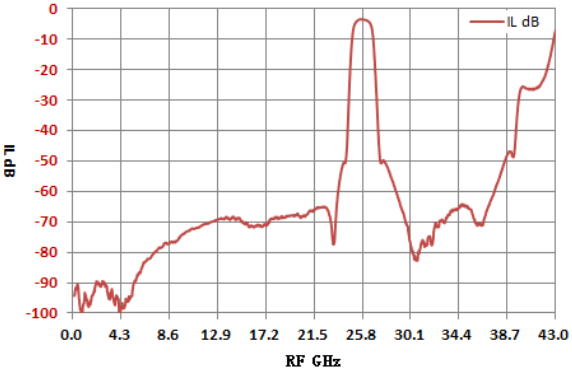
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



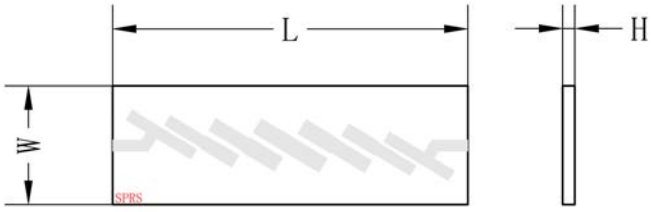
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	26.5	GHz
工作带宽	25.4-27.6	GHz
中心损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-23.8GHz	dBc
带外抑制	40@29.5GHz	dBc

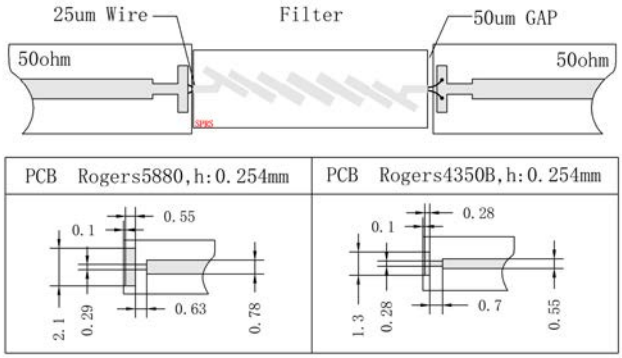
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：10.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



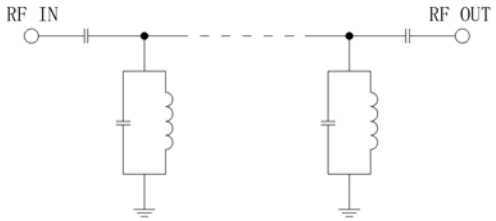
推荐装配图



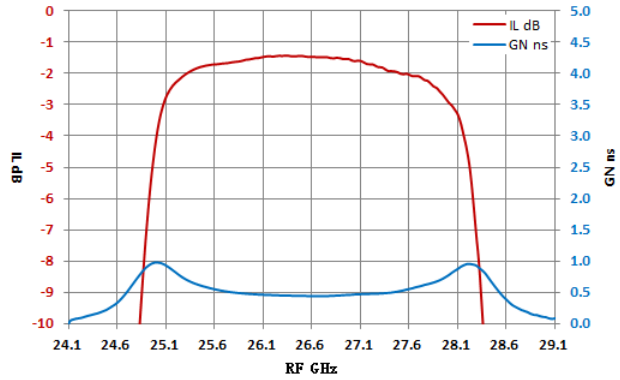
注意事项

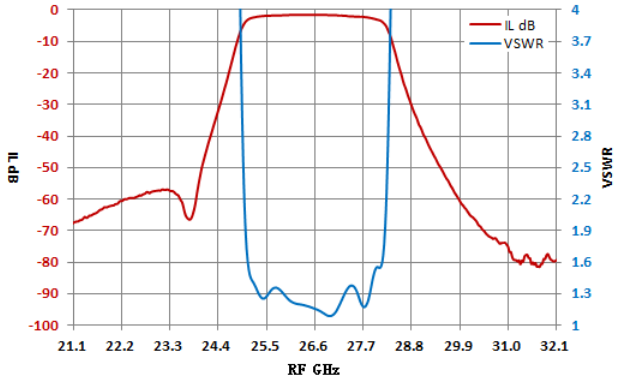
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

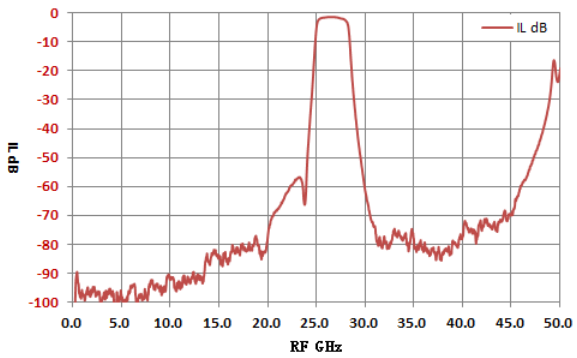
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



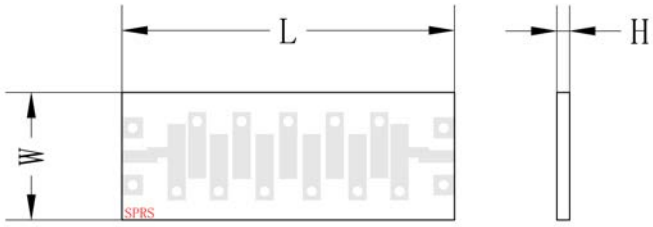
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	28.7	GHz
工作带宽	25.4-32.0	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-22.0GHz	dBc
带外抑制	40@35.0-54.0GHz	dBc

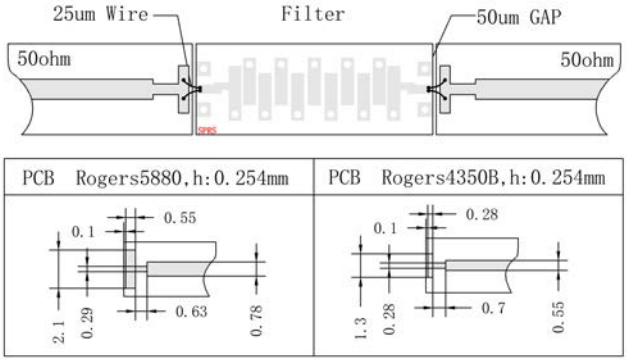
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



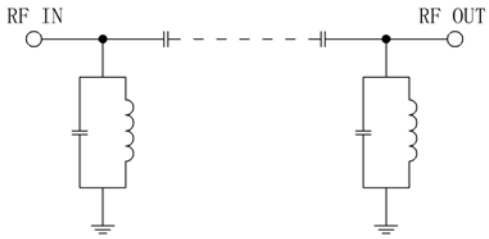
推荐装配图



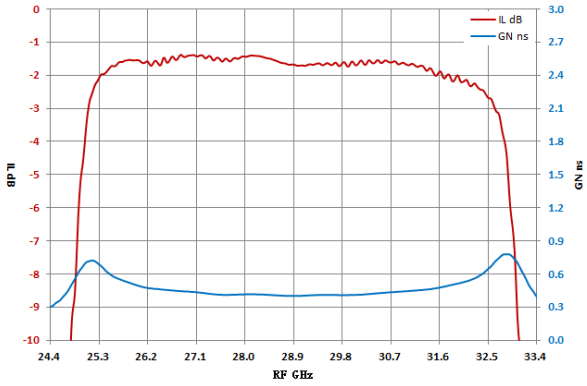
注意事项

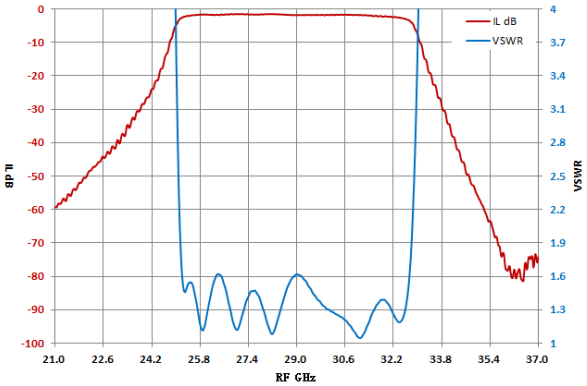
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

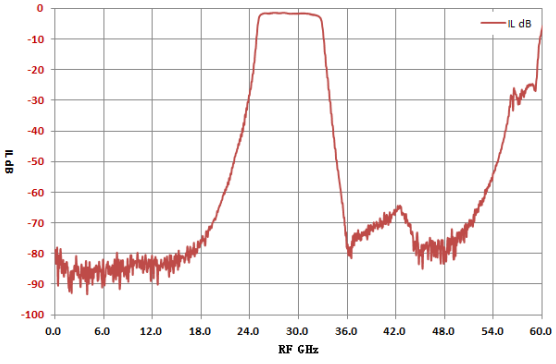
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



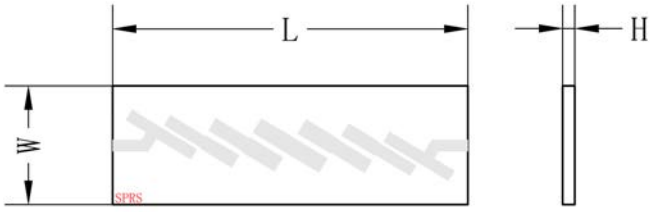
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	25.9	GHz
工作带宽	25.5-26.2	GHz
中心损耗	2.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-24.2GHz	dBc
带外抑制	40@27.5-45.0GHz	dBc

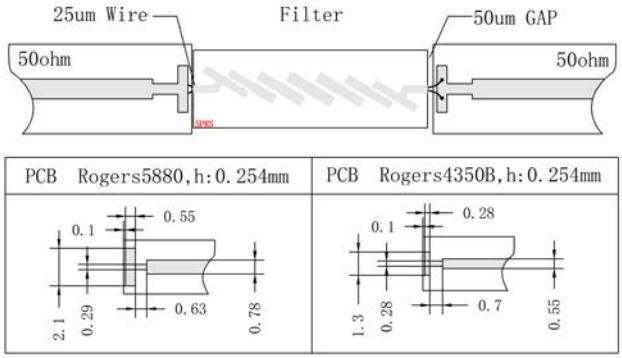
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



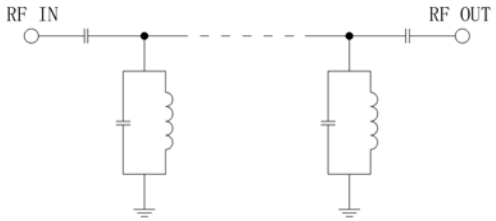
推荐装配图



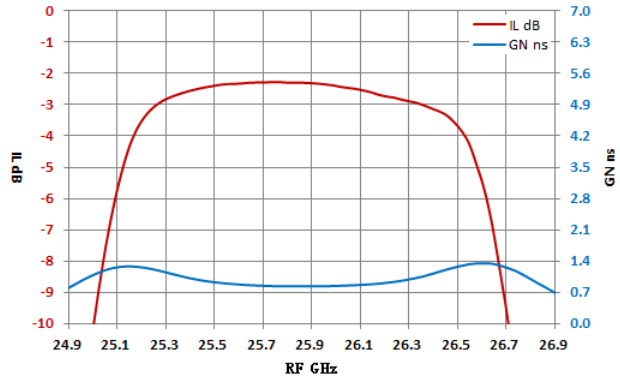
注意事项

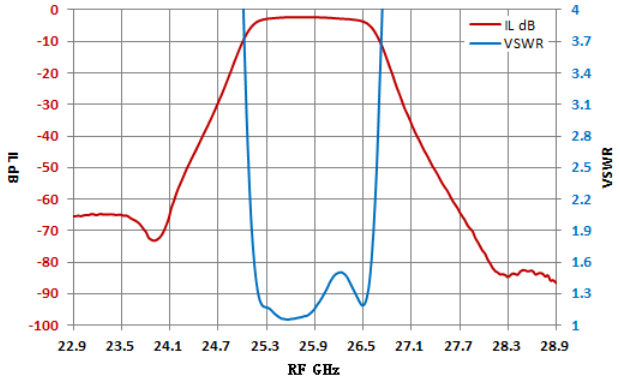
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

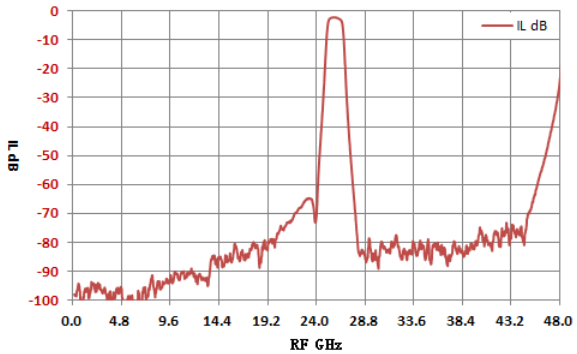
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

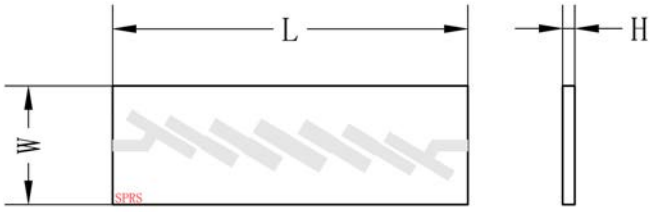
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	33.1	GHz
工作带宽	25.6-40.6	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-15.0GHz	dBc
带外抑制	40@49.0-56.0.GHz	dBc

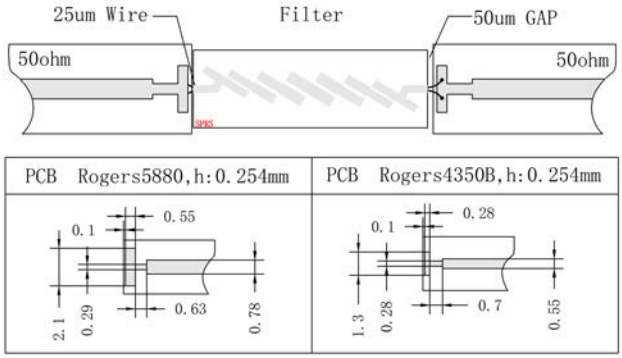
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：4.5，W：1.8，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



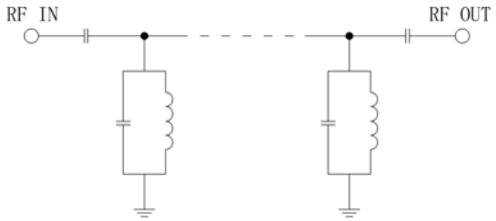
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

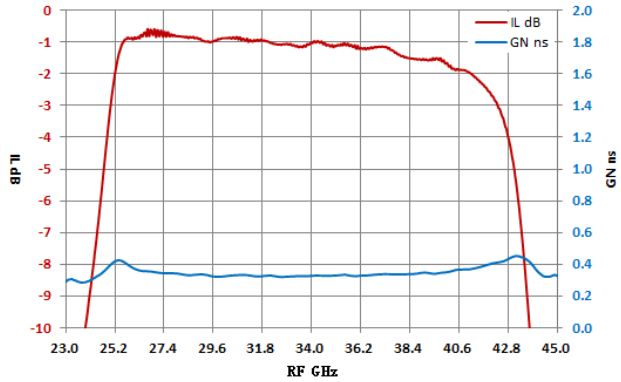
参考实物图

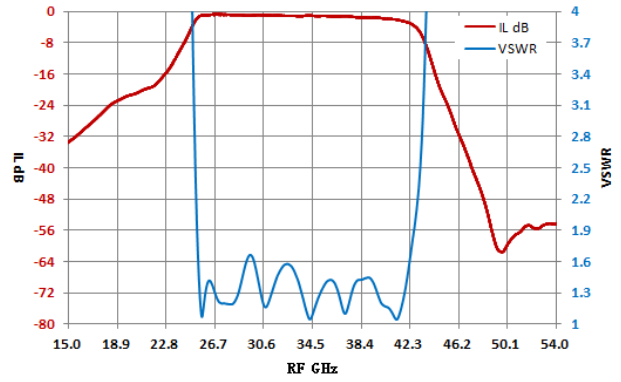


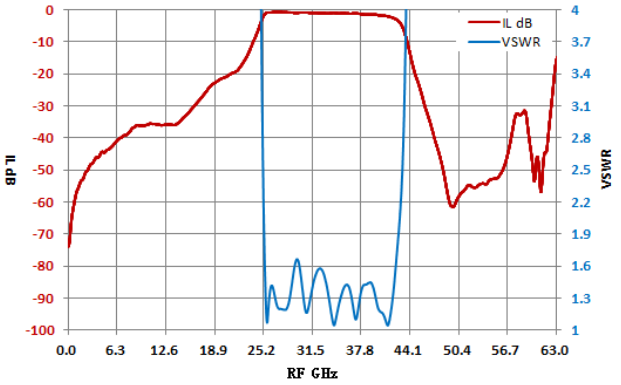
原理图



典型曲线







陶瓷滤波器 STBP267-1R9-K848

工作带宽 25.7-27.6GHz,带外抑制 40@DC-24.0GHz,40@29.5-38.0GHz

产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

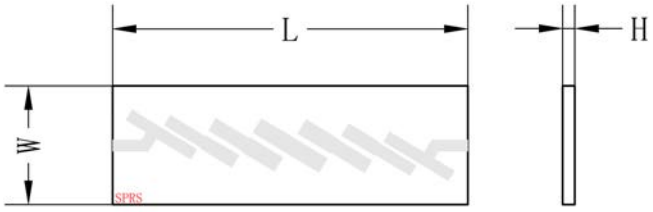
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	26.65	GHz
工作带宽	25.7-27.6	GHz
中心损耗	3.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-23.8GHz	dBc
带外抑制	40@29.3-30.0.0GHz	dBc

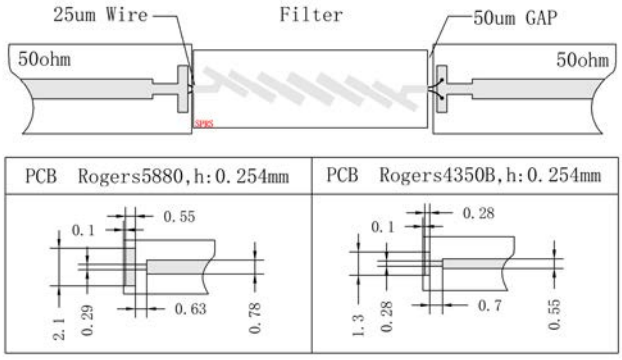
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：5.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



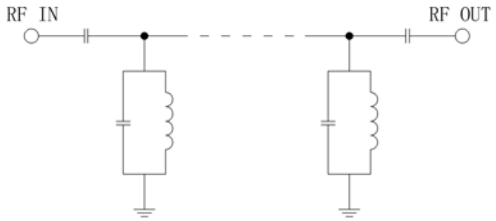
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

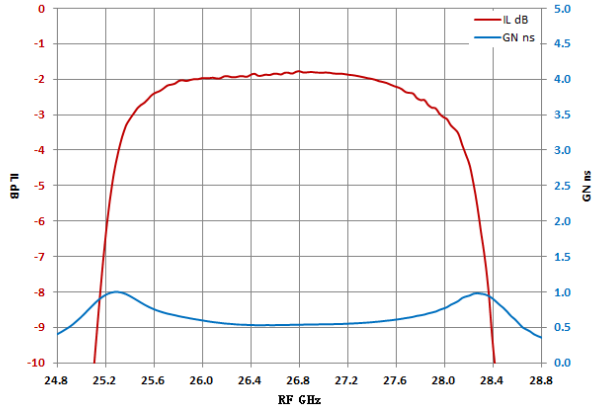
参考实物图

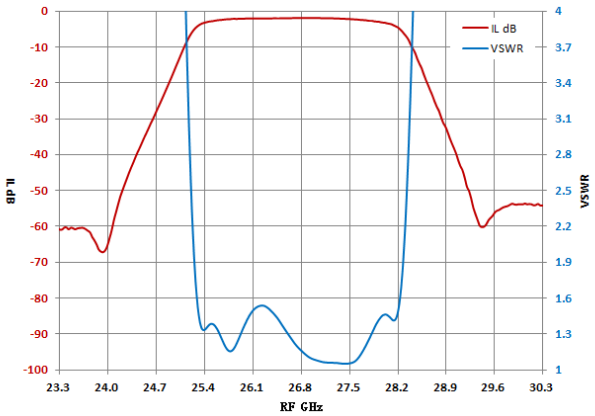


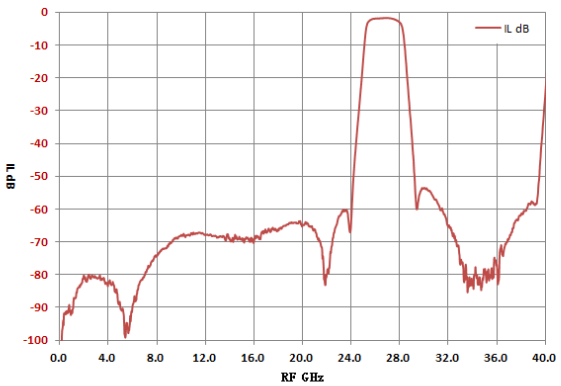
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

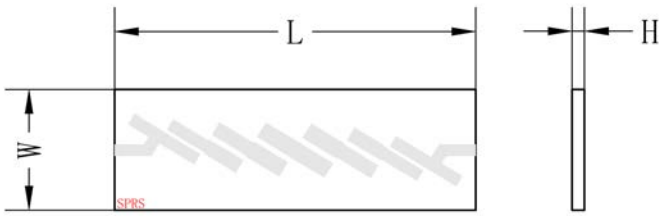
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	27.6	GHz
工作带宽	25.8-29.4	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-23.3GHz	dBc
带外抑制	40@32.8-43.0GHz	dBc

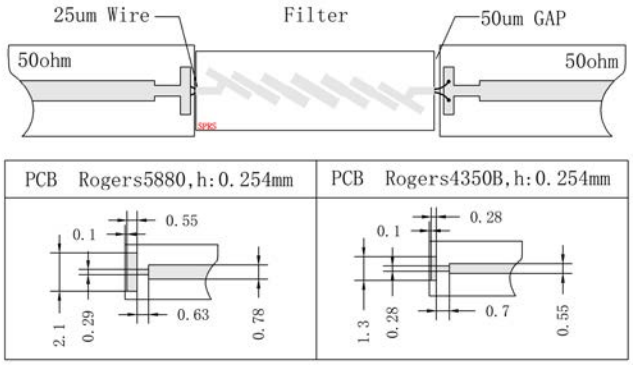
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：5.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

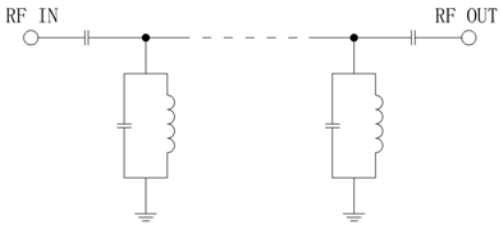
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

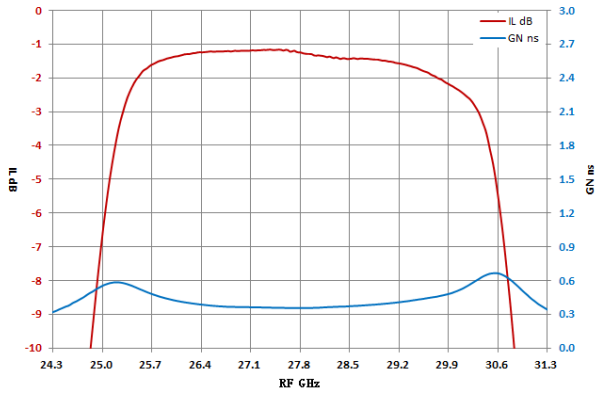
参考图

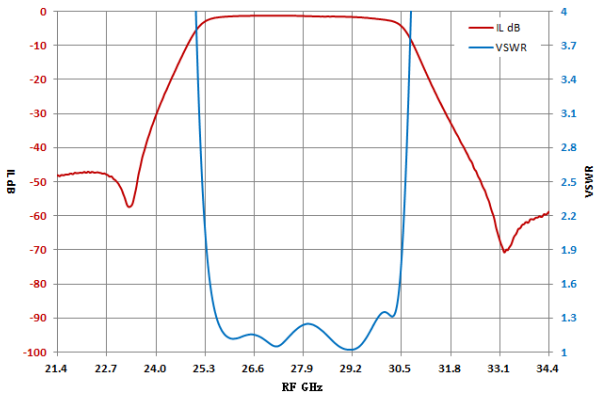


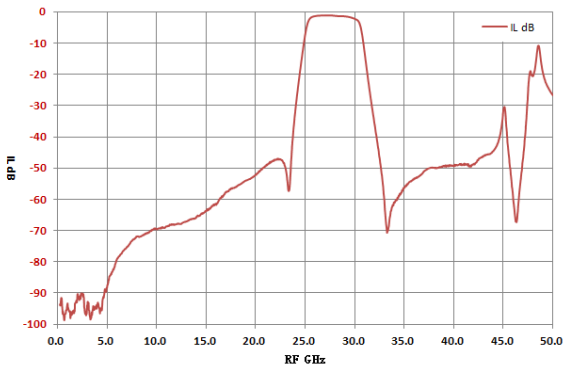
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

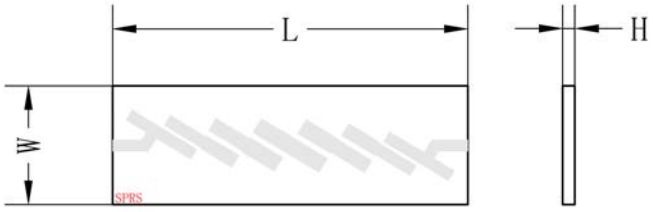
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	27.6	GHz
工作带宽	25.8-29.4	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-23.5GHz	dBc
带外抑制	40@31.3-45.0GHz	dBc

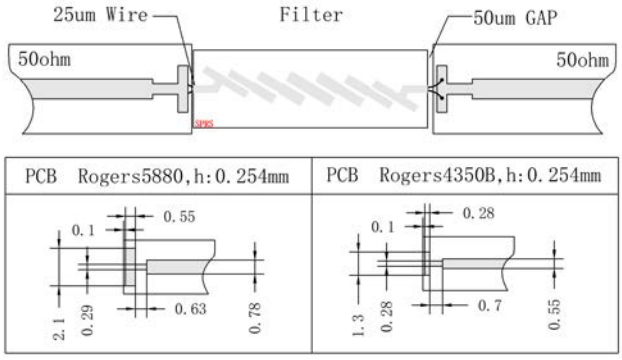
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



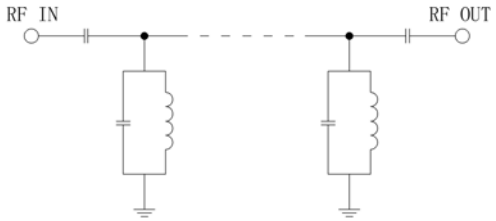
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

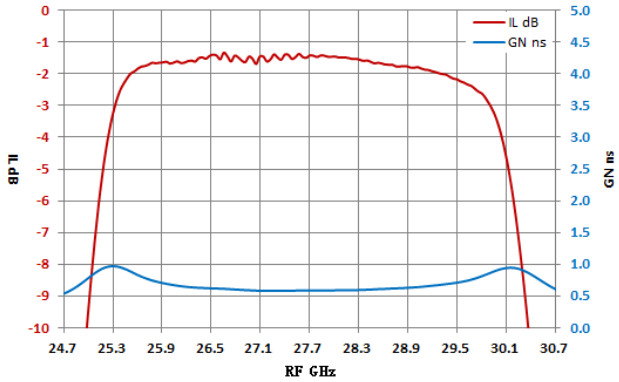
参考实物图

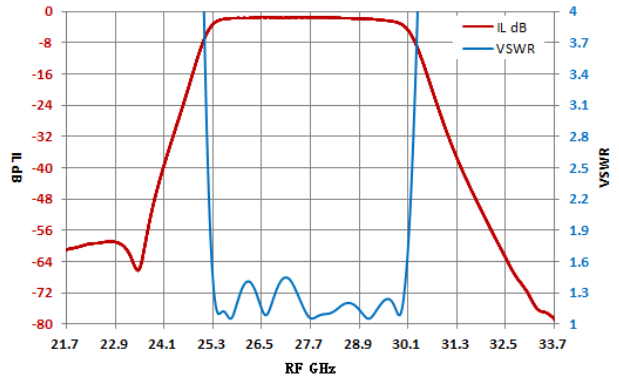


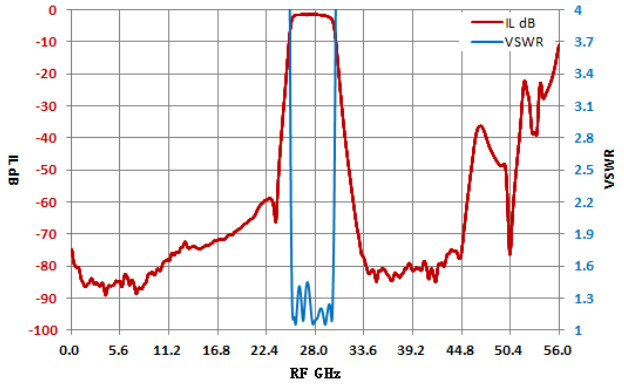
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

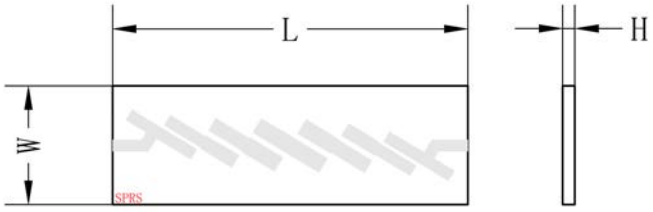
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	26.2	GHz
工作带宽	25.9-26.5	GHz
中心损耗	4.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-23.0GHz	dBc
带外抑制	40@27.9-41.0.0GHz	dBc

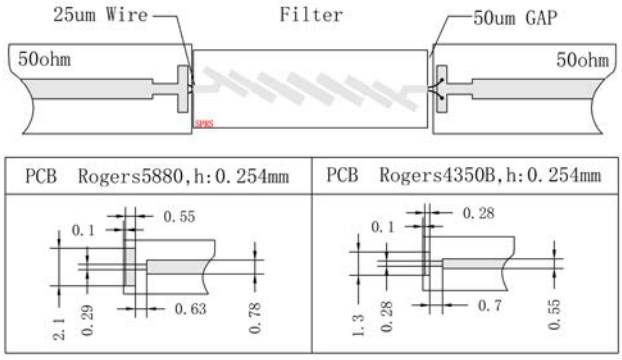
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



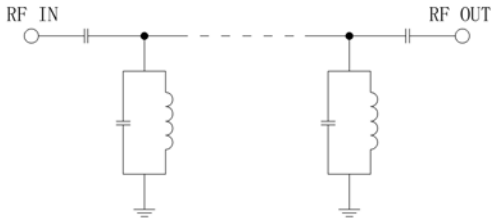
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

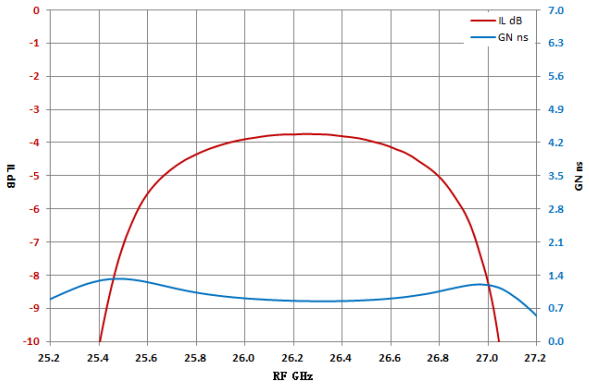
参考实物图

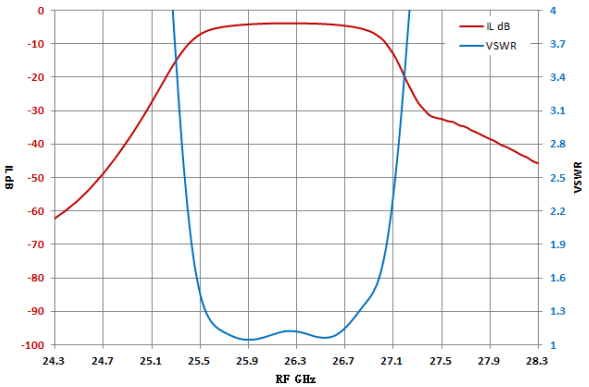


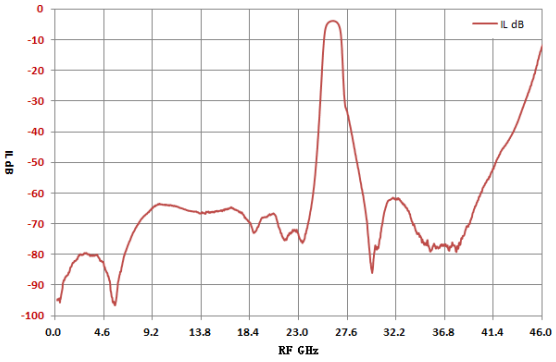
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

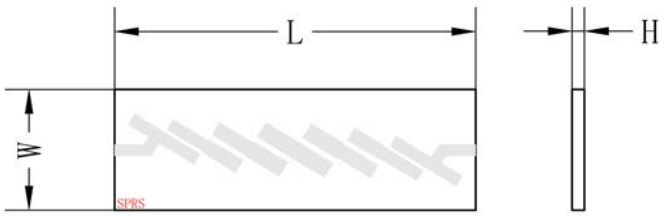
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	26.3	GHz
工作带宽	25.9-26.7	GHz
中心损耗	3.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-24.6GHz	dBc
带外抑制	40@28.1-47.0GHz	dBc

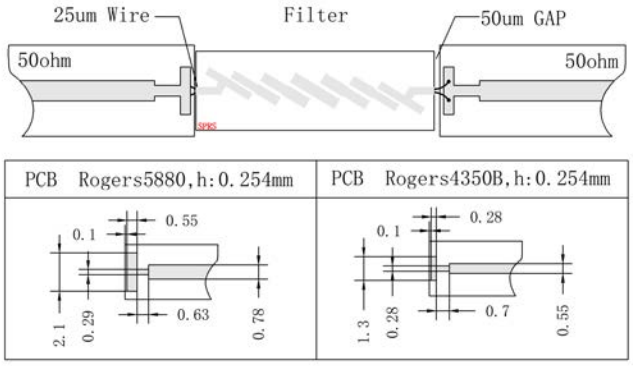
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

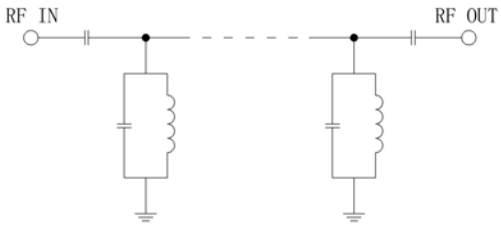
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

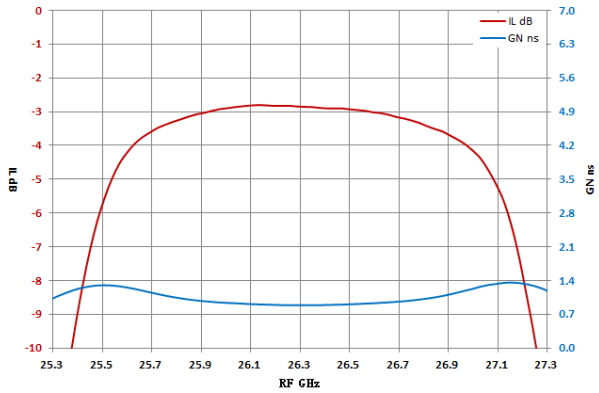
参考图

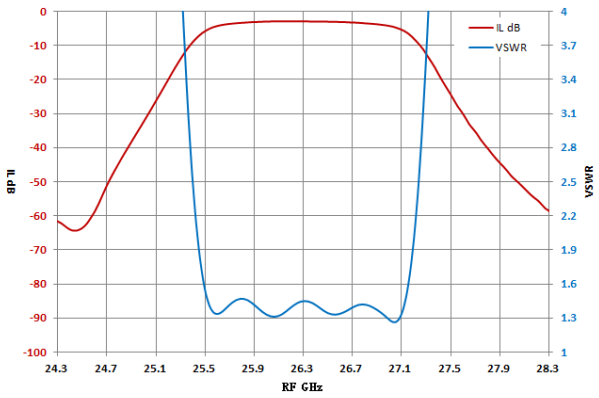


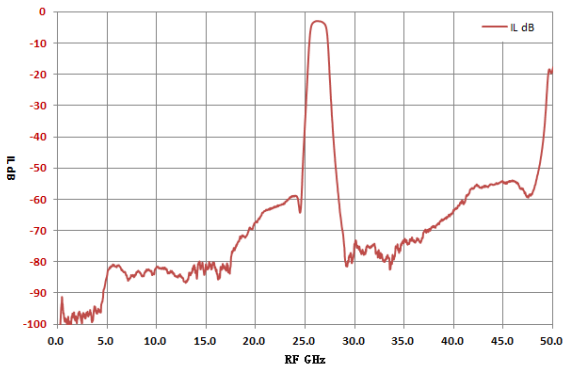
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



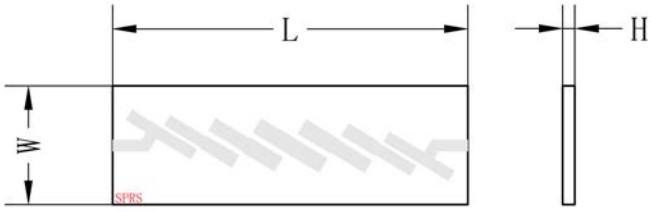
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	26.7	GHz
工作带宽	25.9-27.5	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	30@DC-24.6GHz	dBc
带外抑制	40@29.1-37.0GHz	dBc

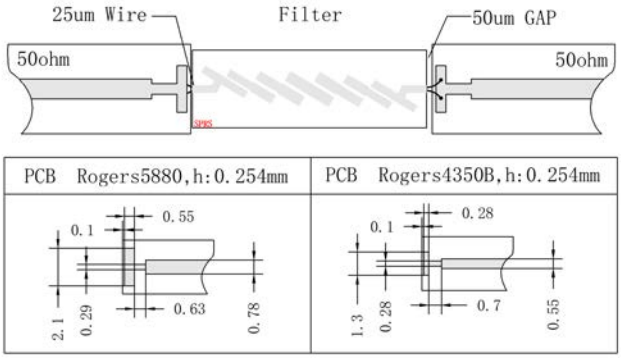
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：5.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



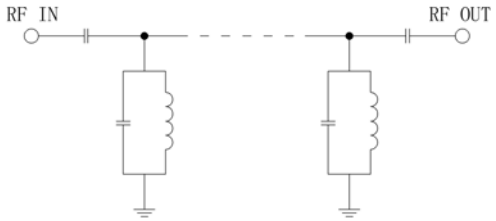
推荐装配图



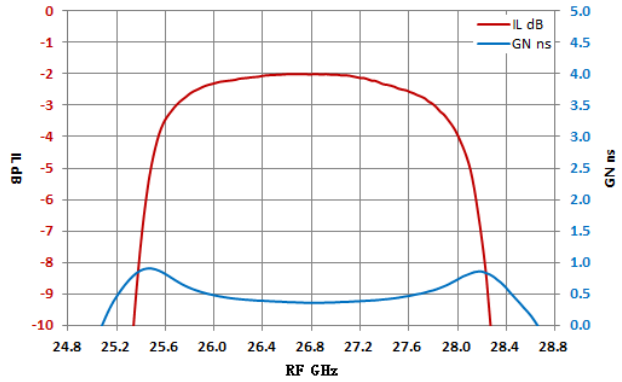
注意事项

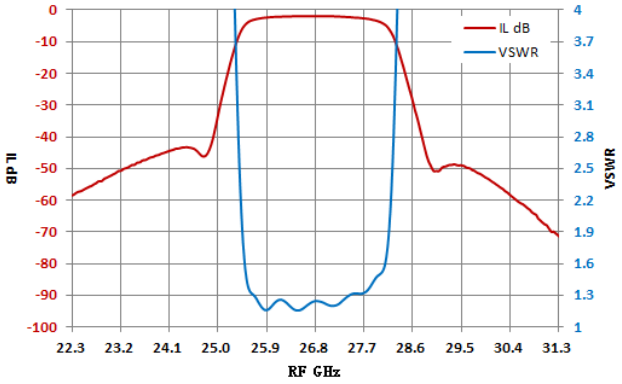
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

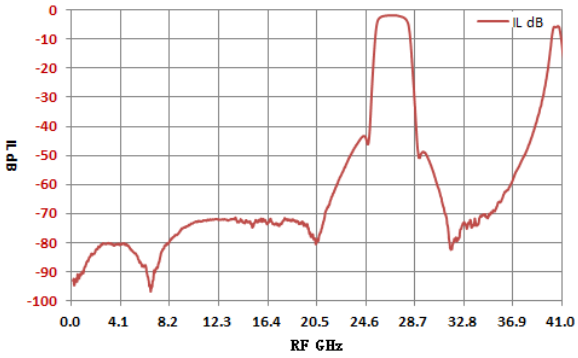
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

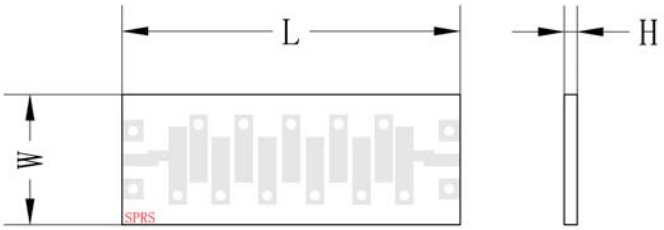
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	26.9	GHz
工作带宽	26.0-27.8	GHz
中心损耗	2.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-24.4GHz	dBc
带外抑制	40@29.5-44.0GHz	dBc

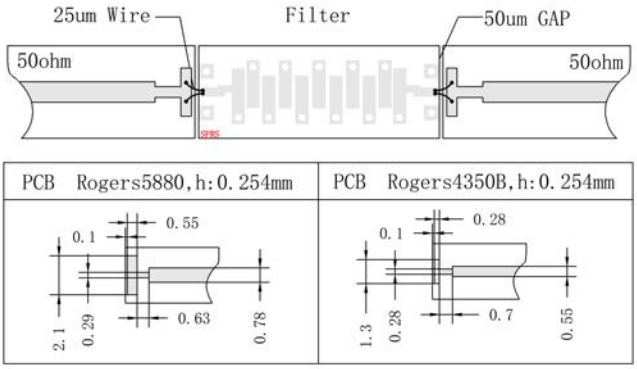
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：6.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

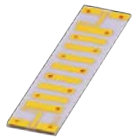
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

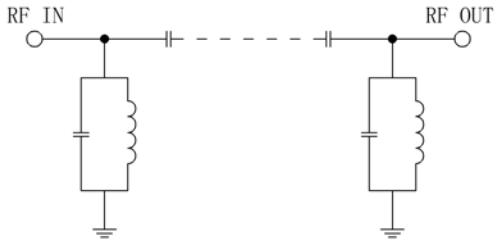
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

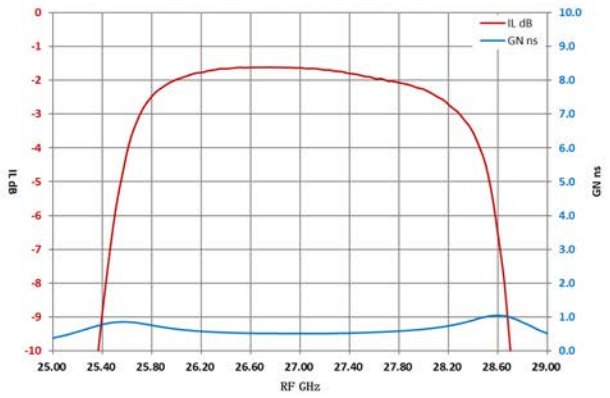
参考图

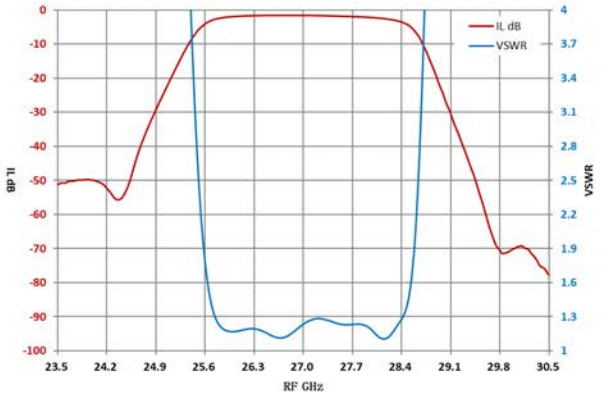


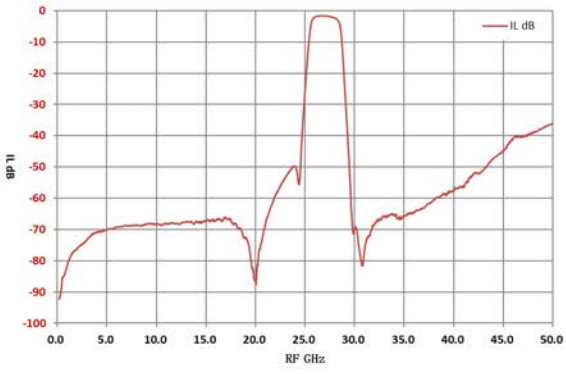
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

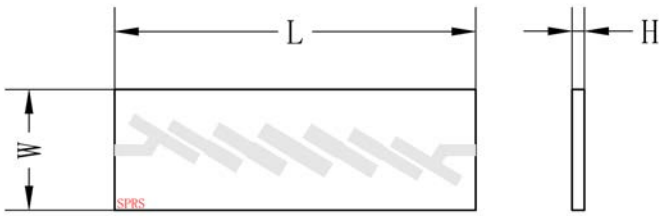
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	28.1	GHz
工作带宽	26.0-30.2	GHz
中心损耗	1.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	38@DC-23.8GHz	dBc
带外抑制	38@33.2-44.0GHz	dBc

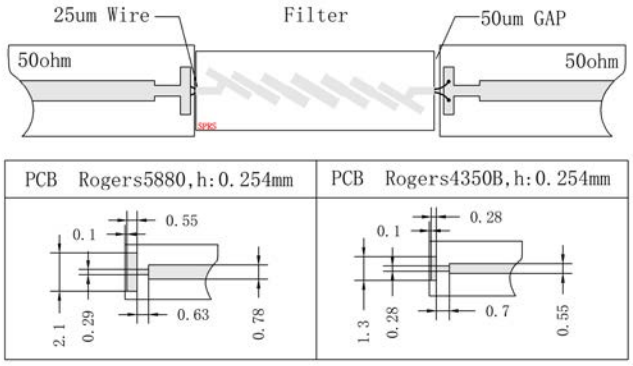
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：6.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

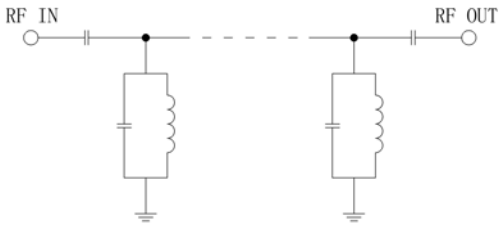
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

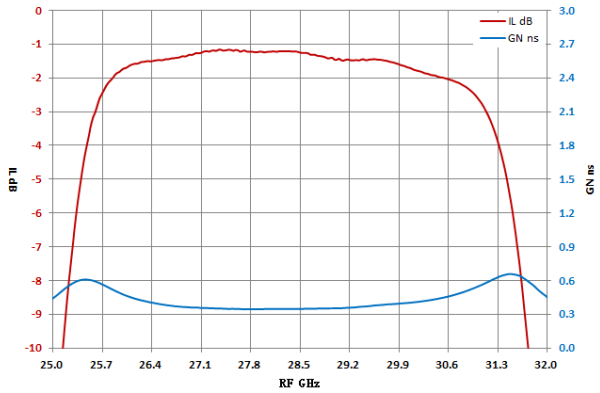
参考图

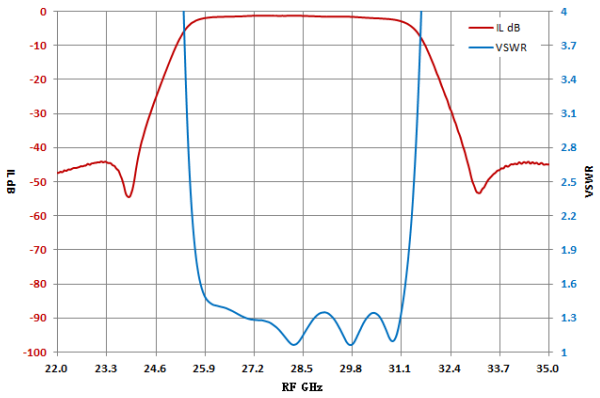


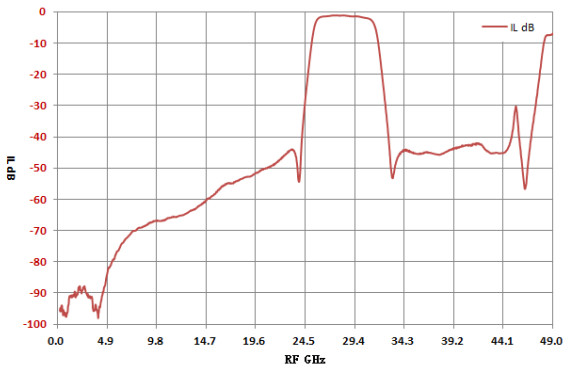
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

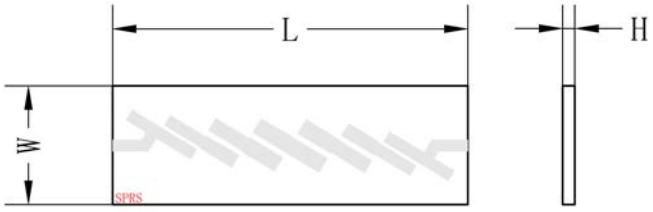
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	29.8	GHz
工作带宽	26.0-33.6	GHz
中心损耗	1.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-23.6GHz	dBc
带外抑制	40@38.6-50.0GHz	dBc

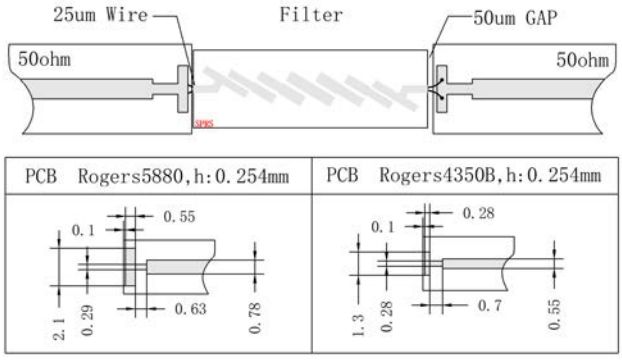
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



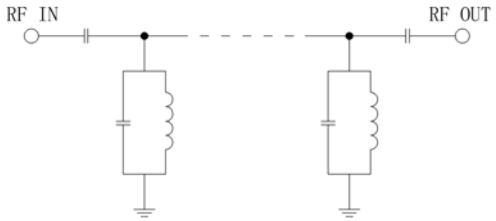
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

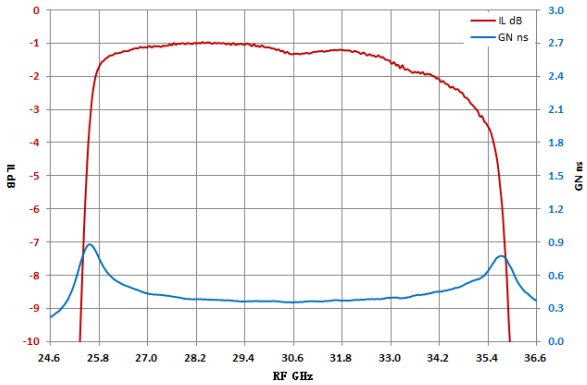
参考实物图

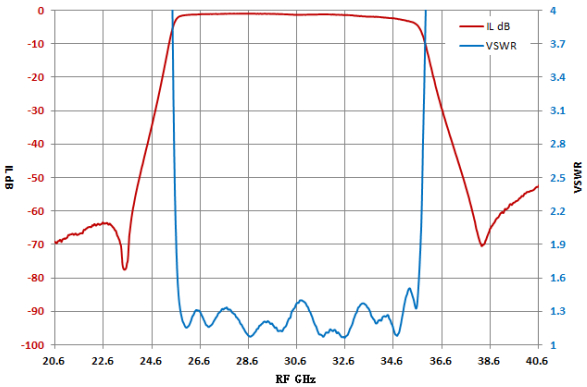


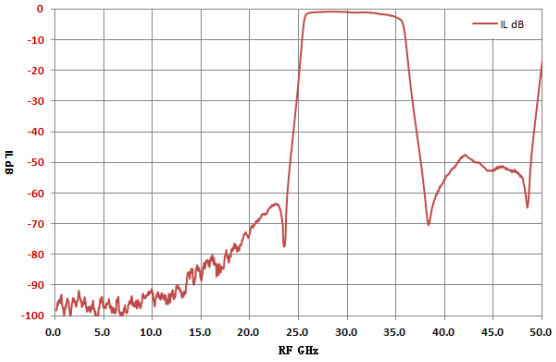
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



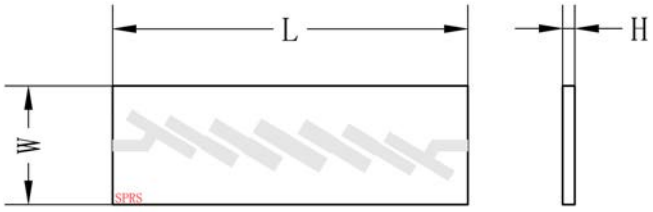
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	32.3	GHz
工作带宽	26.0-38.6	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-22.5GHz	dBc
带外抑制	40@44.5-47.0GHz	dBc

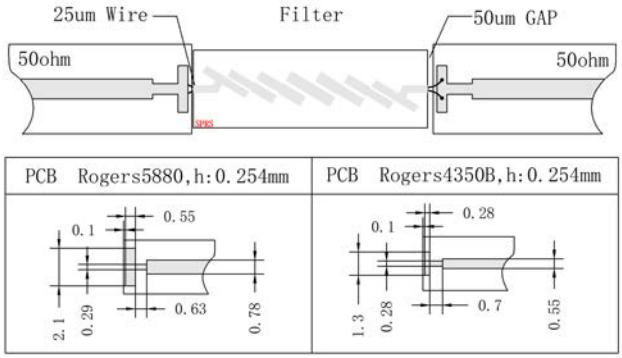
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：10.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



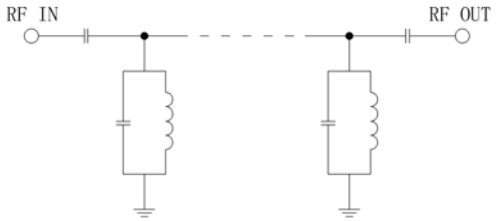
推荐装配图



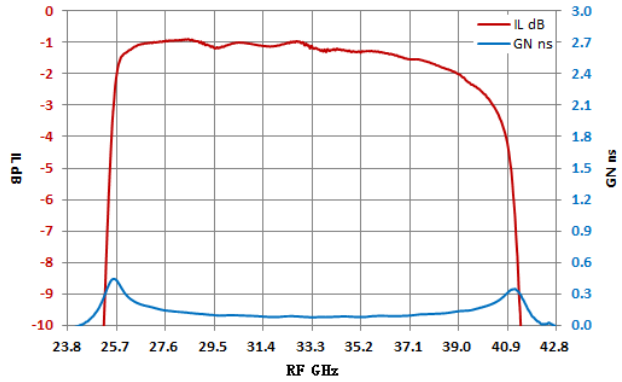
注意事项

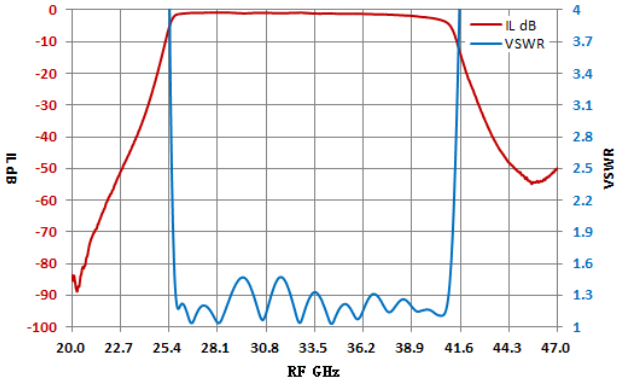
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

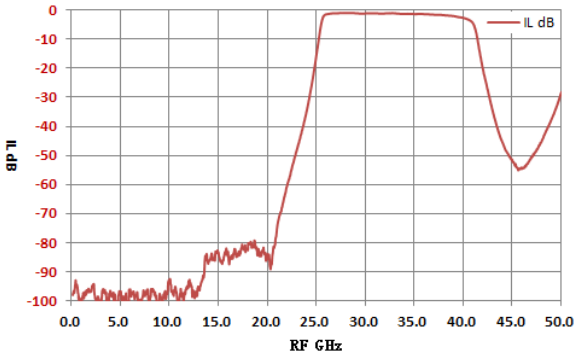
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



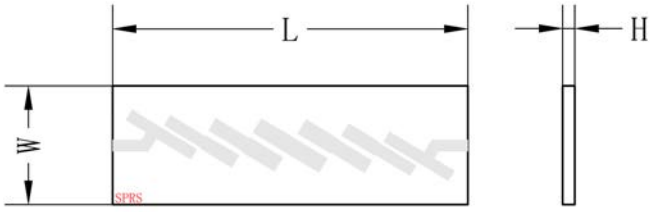
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	26.7	GHz
工作带宽	26.2-27.1	GHz
中心损耗	3.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-25.2GHz	dBc
带外抑制	40@28.2-41.0GHz	dBc

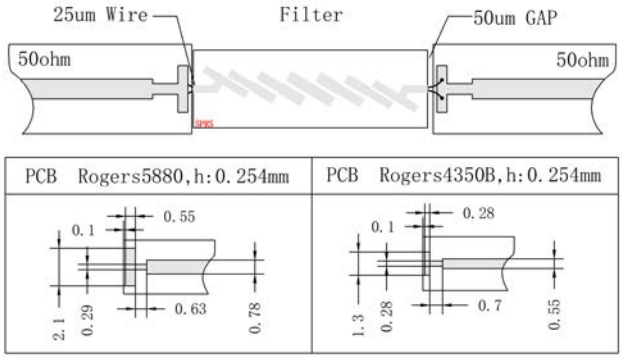
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：10.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



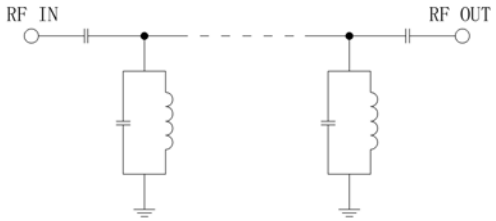
推荐装配图



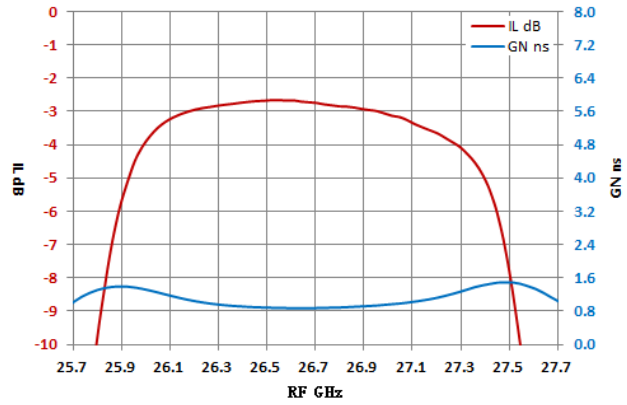
注意事项

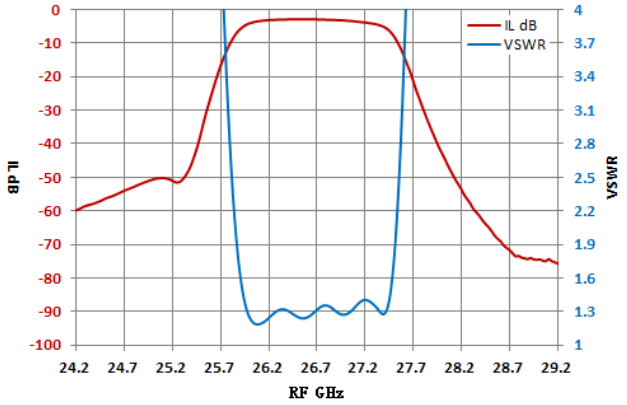
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

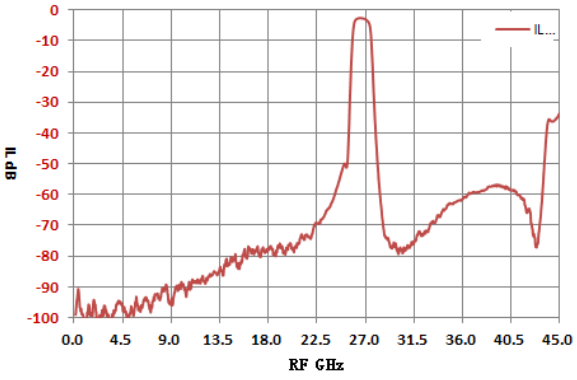
原理图



典型曲线







陶瓷滤波器 STBP312-100-M410

工作带宽 26.2-36.2GHz,带外抑制 40@DC-21.0GHz,40@41.0-56.0GHz

产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



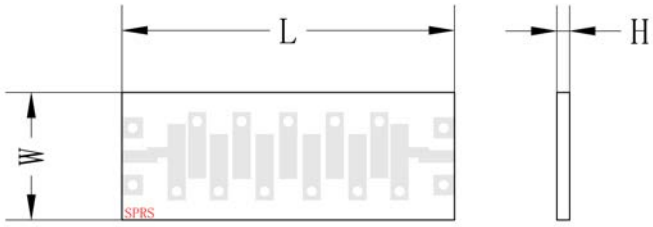
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	31.2	GHz
工作带宽	26.2-36.2	GHz
中心损耗	1.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-21.0GHz	dBc
带外抑制	40@41.0-56.0GHz	dBc

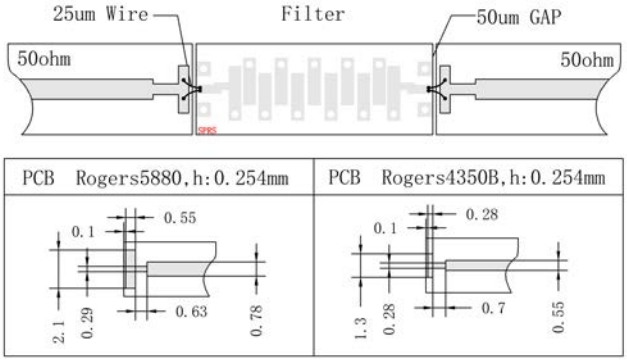
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



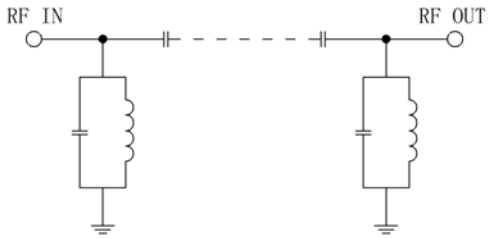
推荐装配图



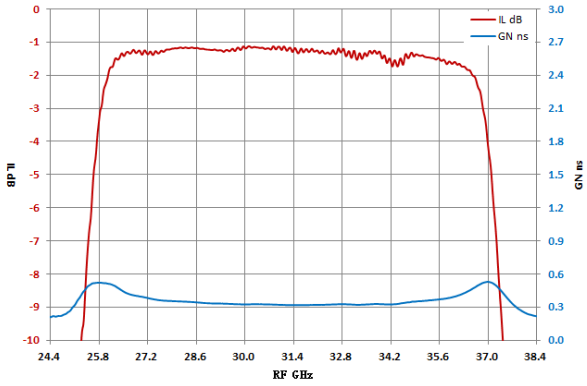
注意事项

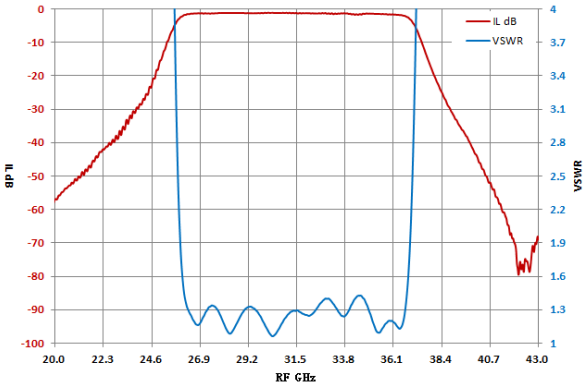
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

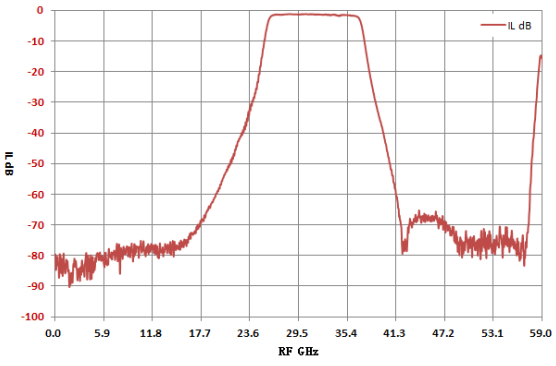
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



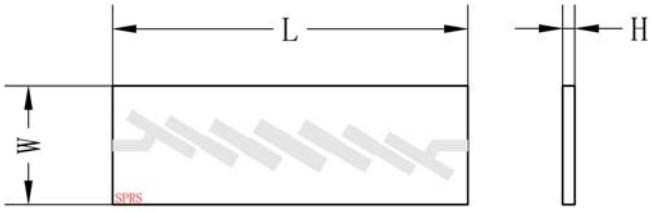
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	26.8	GHz
工作带宽	26.3-27.3	GHz
中心损耗	3.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-24.6GHz	dBc
带外抑制	40@29.1-35.0GHz	dBc

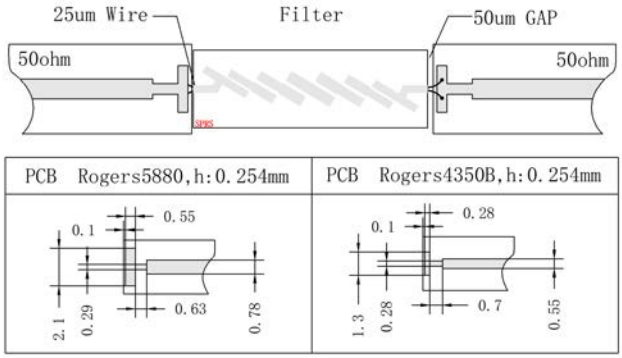
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：5.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



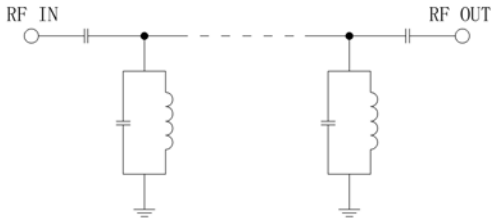
推荐装配图



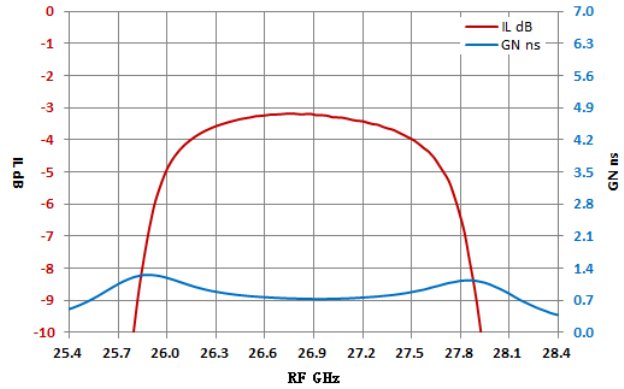
注意事项

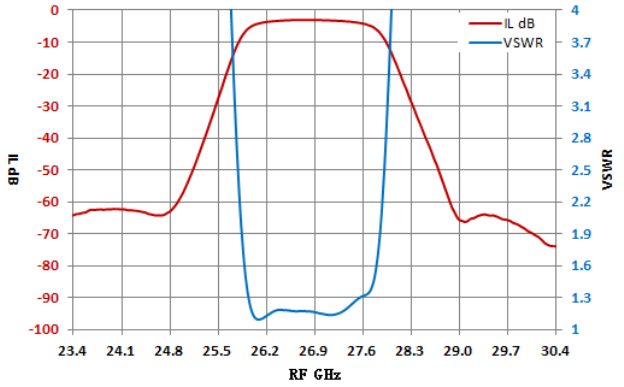
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

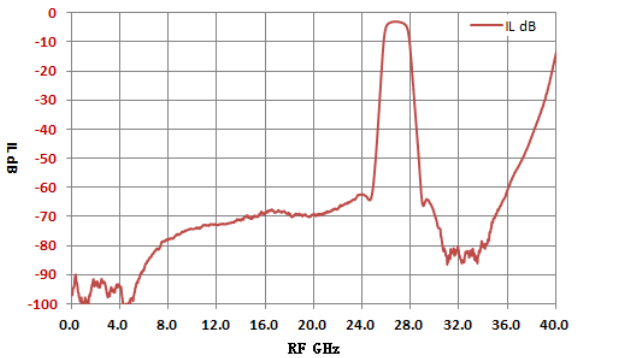
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



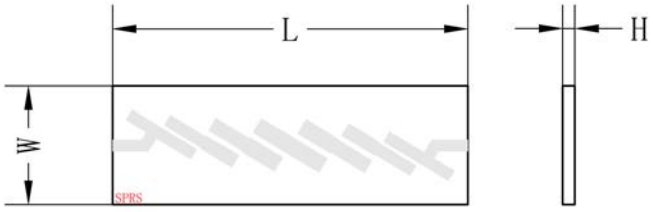
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	27.0	GHz
工作带宽	26.3-27.7	GHz
中心损耗	3.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-25.0GHz	dBc
带外抑制	40@29.4-36.0GHz	dBc

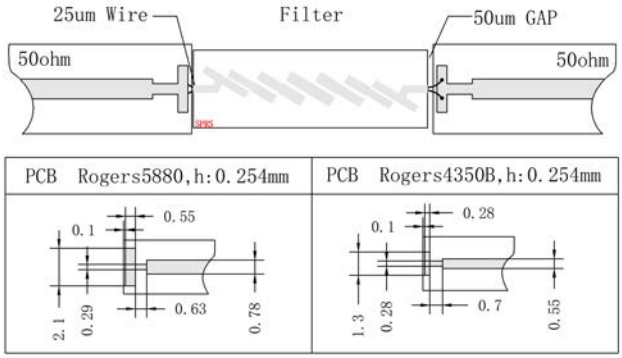
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：5.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



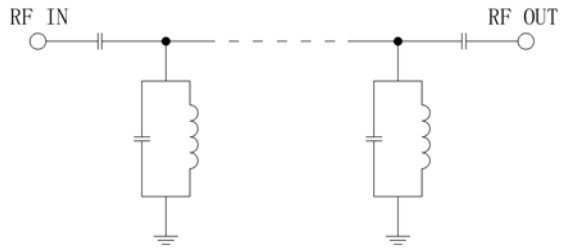
推荐装配图



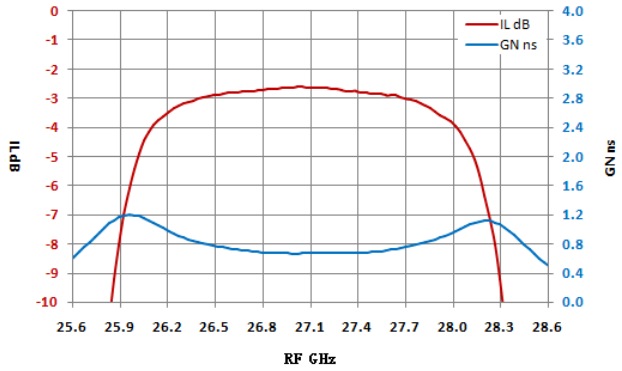
注意事项

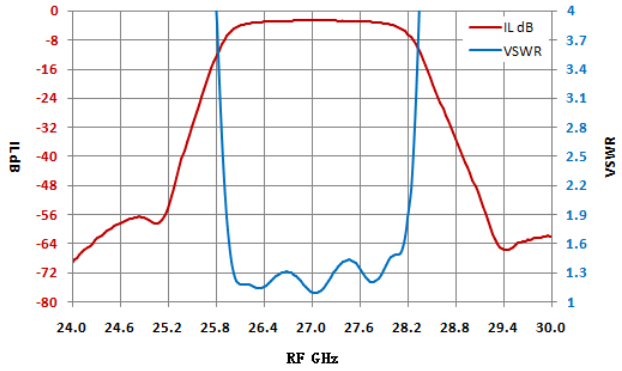
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

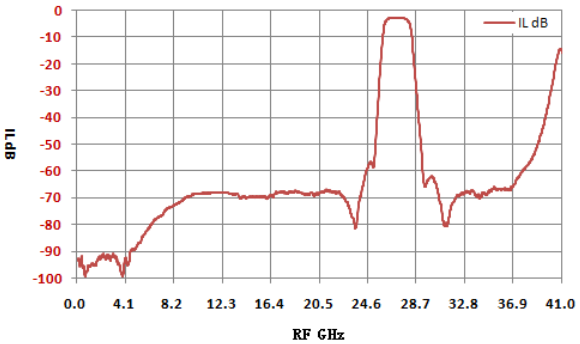
原理图



典型曲线







陶瓷滤波器 STBP290-5R2-K408

工作带宽 26.4-31.6GHz,带外抑制 40@DC-24.0GHz,40@33.9-56.0GHz

产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



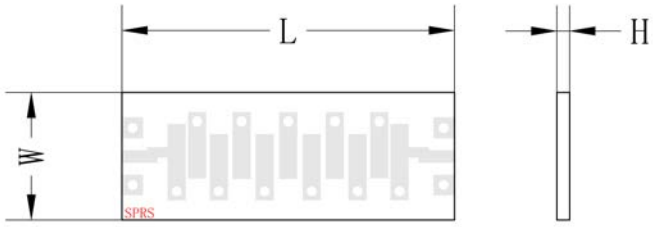
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	29.0	GHz
工作带宽	26.4-31.6	GHz
中心损耗	3.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-24.0GHz	dBc
带外抑制	40@33.9-56.0GHz	dBc

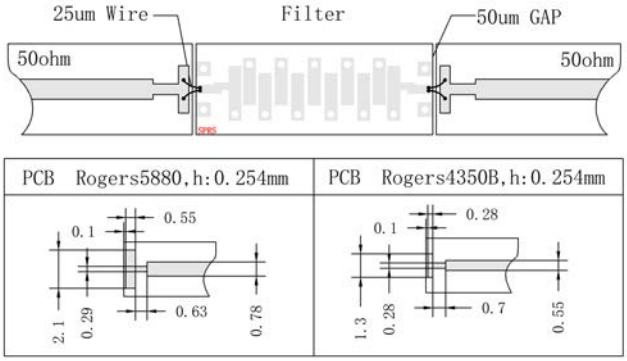
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



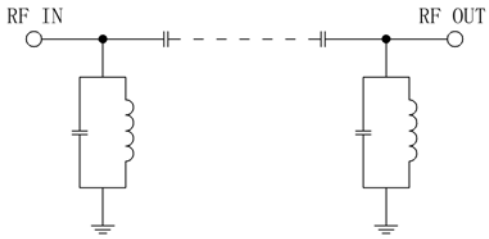
推荐装配图



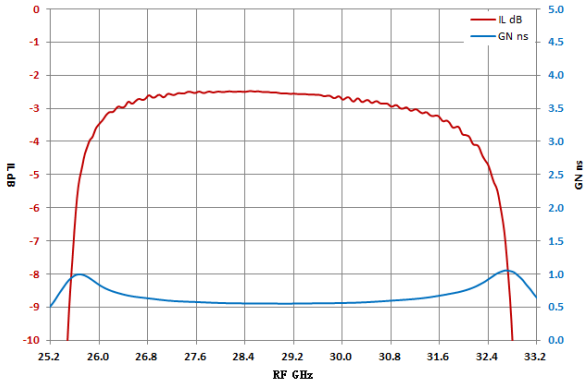
注意事项

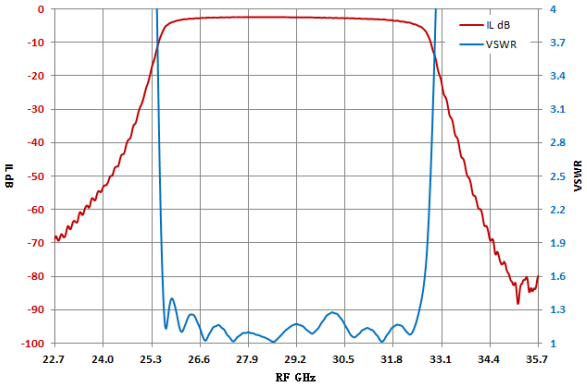
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

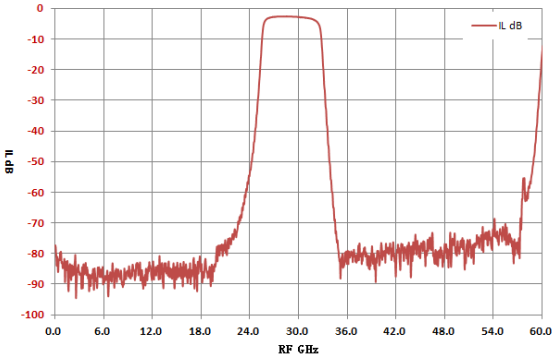
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



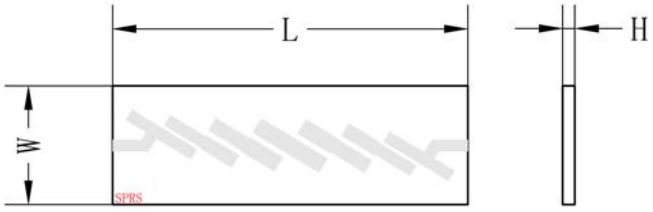
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	32.0	GHz
工作带宽	26.5-37.5	GHz
中心损耗	1.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-23.7GHz	dBc
带外抑制	40@42.0-49.0GHz	dBc

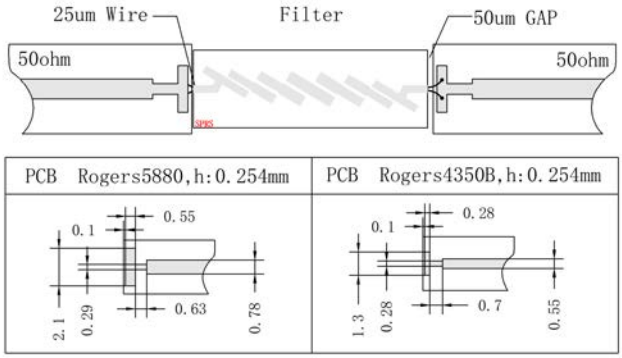
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：10.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



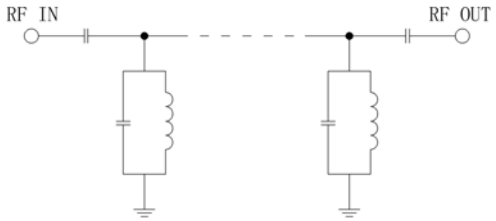
推荐装配图



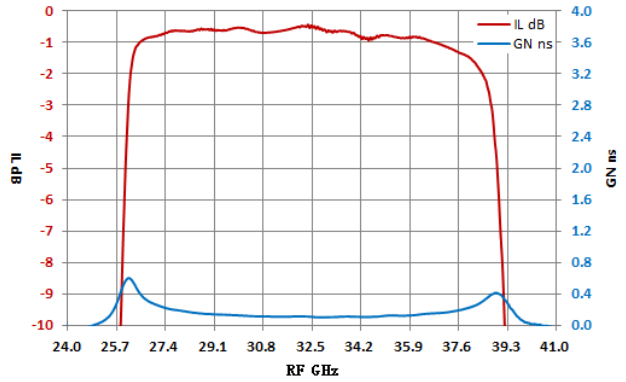
注意事项

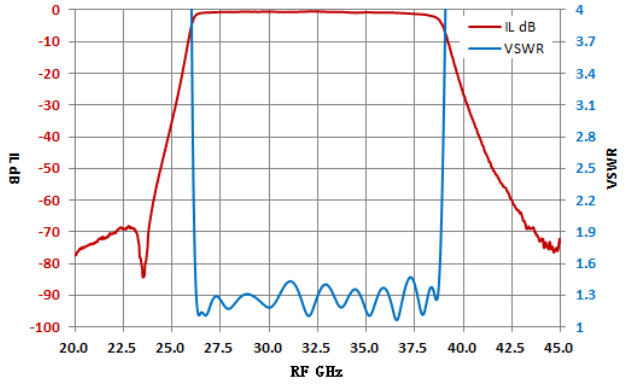
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

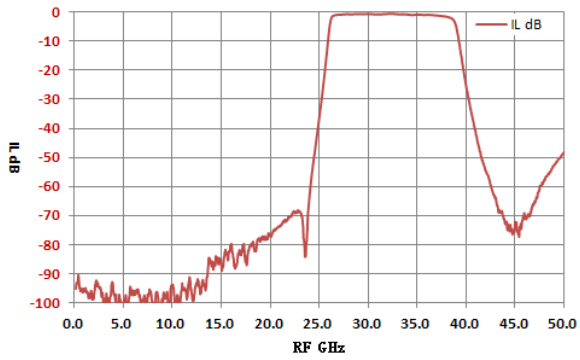
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



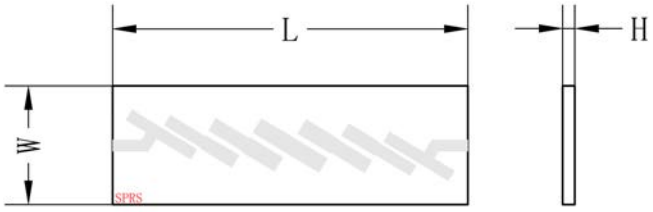
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	28.6	GHz
工作带宽	26.6-30.6	GHz
中心损耗	1.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-24.3GHz	dBc
带外抑制	40@33.5-47.0GHz	dBc

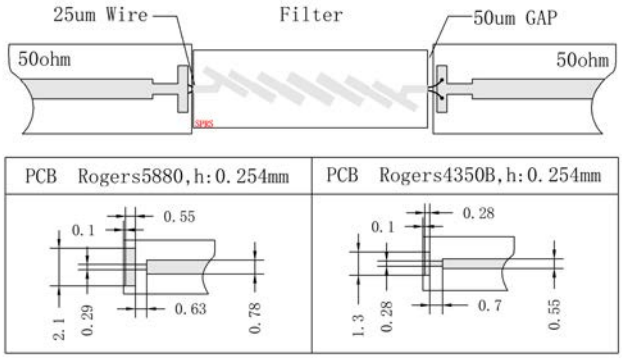
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



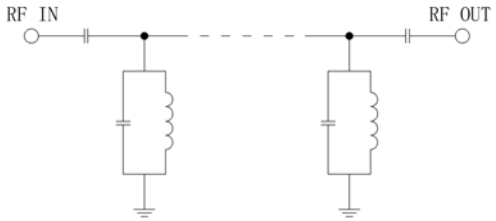
推荐装配图



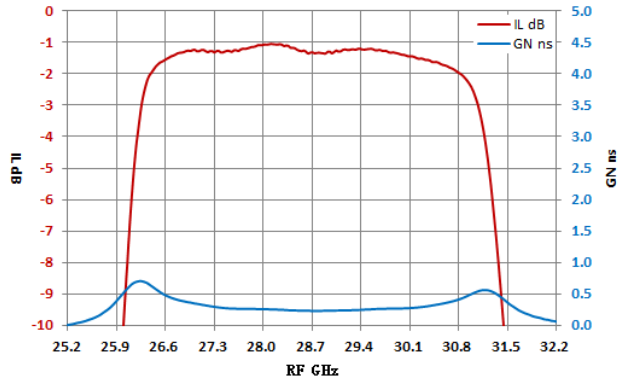
注意事项

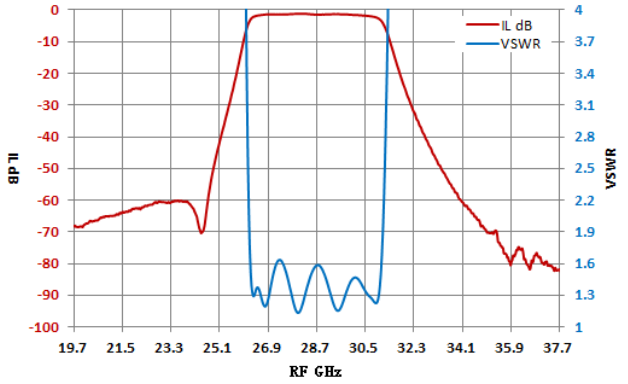
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

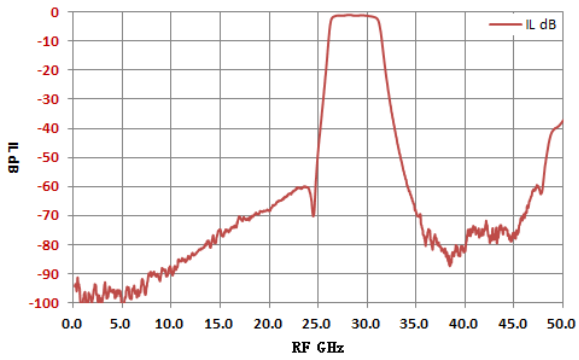
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



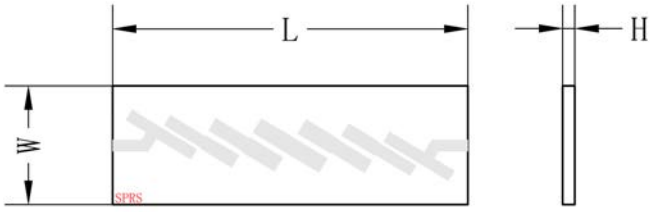
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	29.0	GHz
工作带宽	26.7-31.3	GHz
中心损耗	1.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-24.3GHz	dBc
带外抑制	40@34.4-46.0GHz	dBc

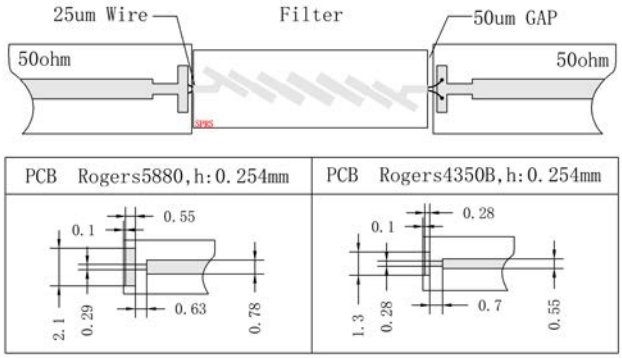
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



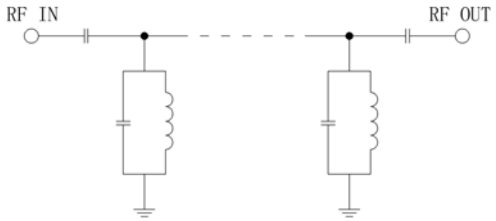
推荐装配图



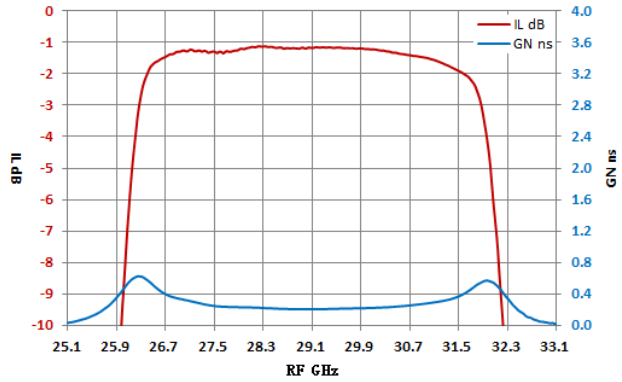
注意事项

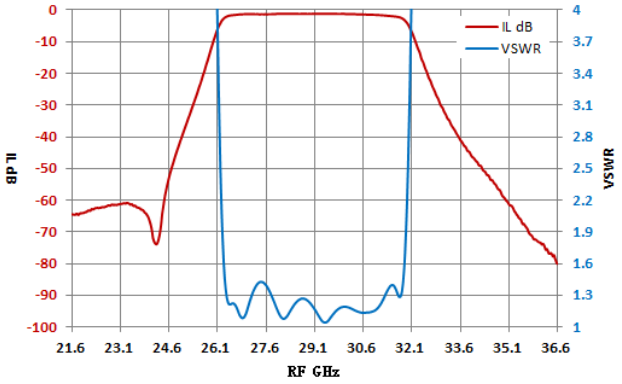
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

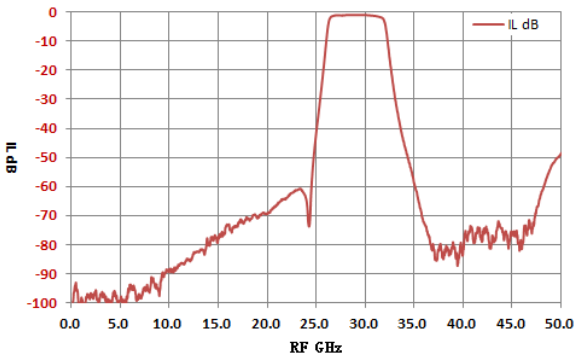
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

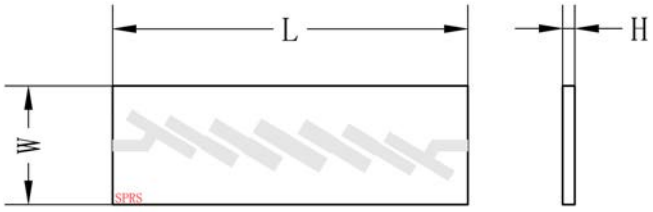
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	33.1	GHz
工作带宽	26.8-39.4	GHz
中心损耗	1.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-21.1GHz	dBc
带外抑制	40@46.2-49.0GHz	dBc

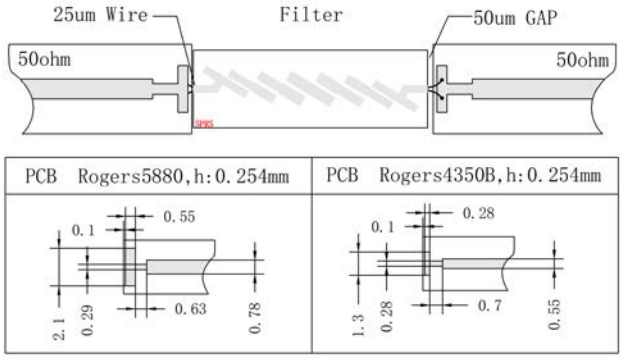
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



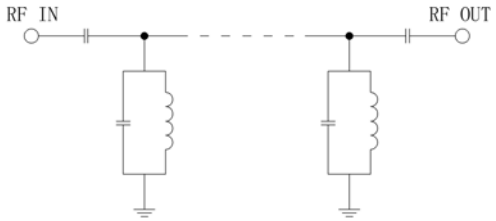
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.87mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

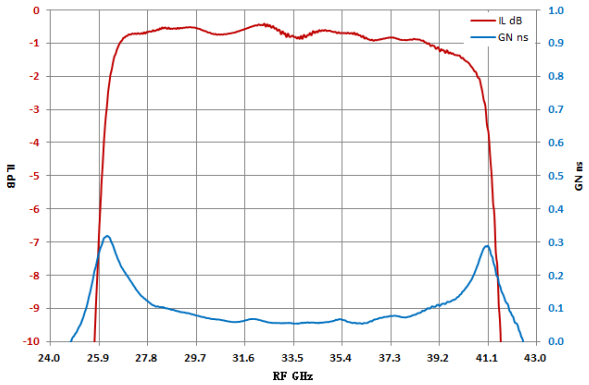
参考实物图

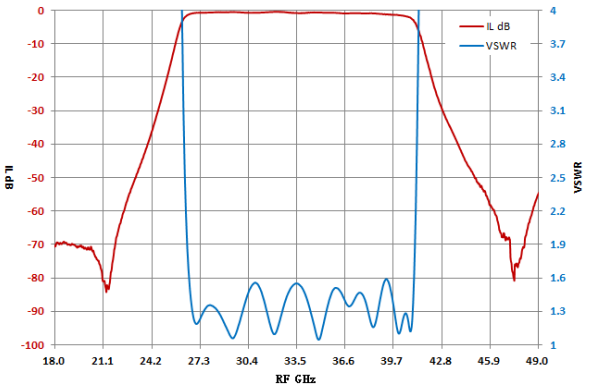


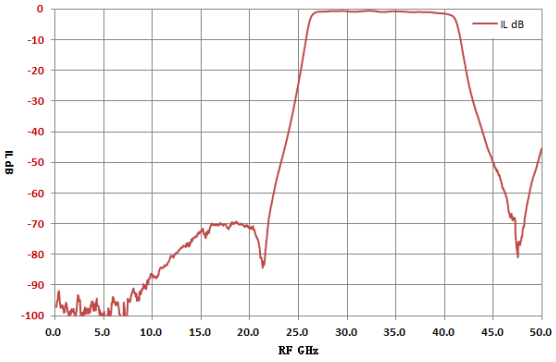
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

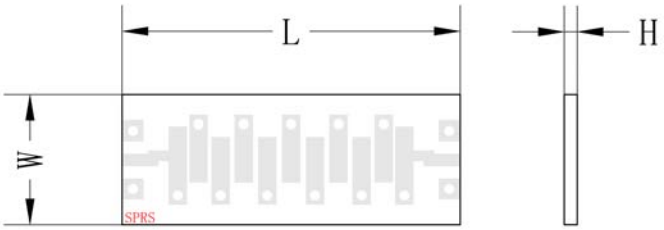
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	27.9	GHz
工作带宽	26.9-28.9	GHz
中心损耗	2.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-25.2GHz	dBc
带外抑制	50@30.6-44.0GHz	dBc

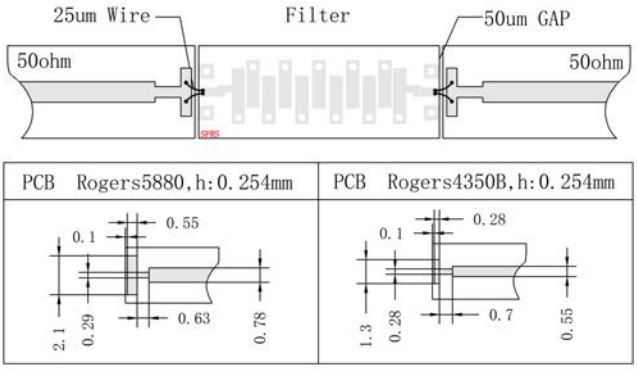
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：6.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

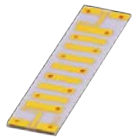
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

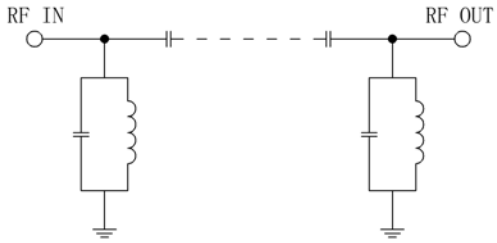
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

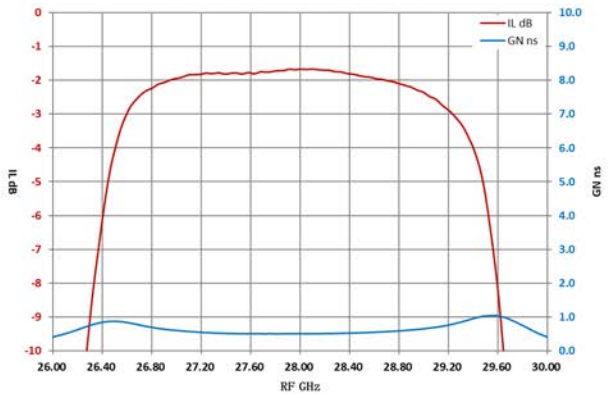
参考图

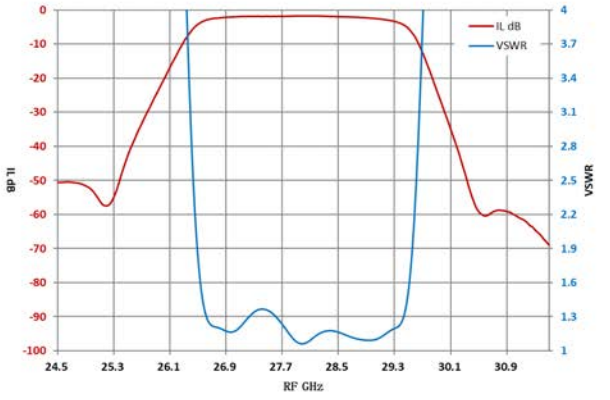


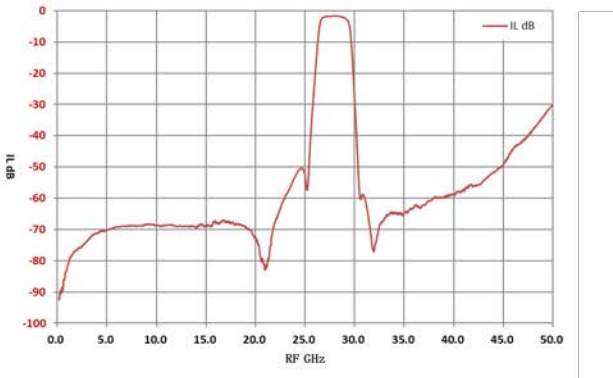
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

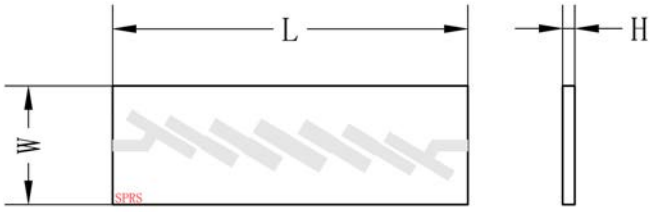
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	31.0	GHz
工作带宽	27.0-35.0	GHz
中心损耗	1.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-20.0GHz	dBc
带外抑制	40@43.0-50.0GHz	dBc

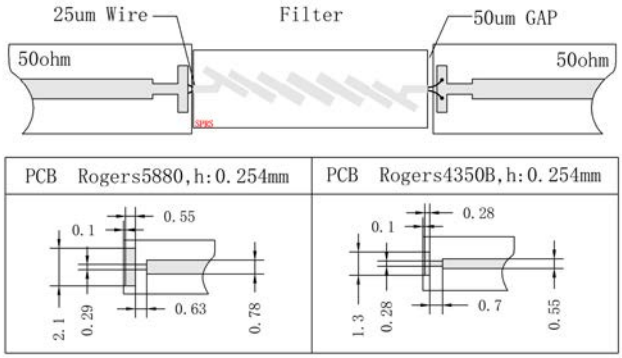
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



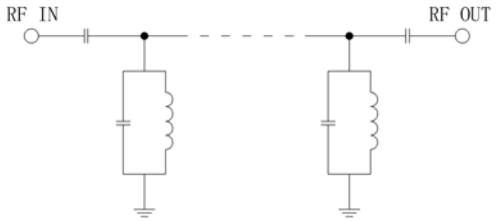
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.74mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

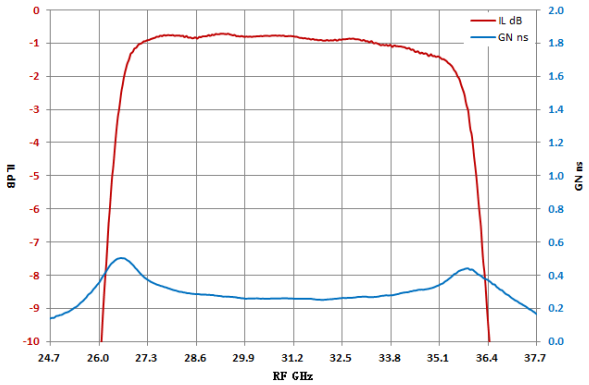
参考实物图

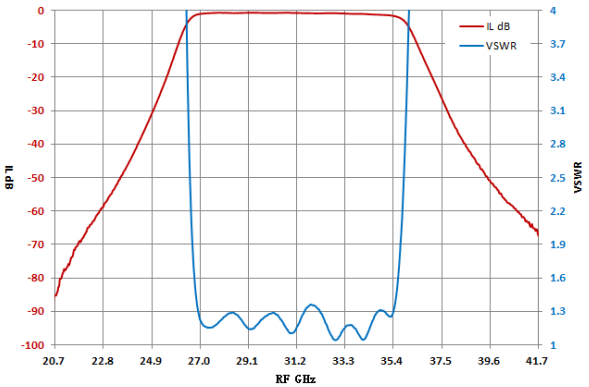


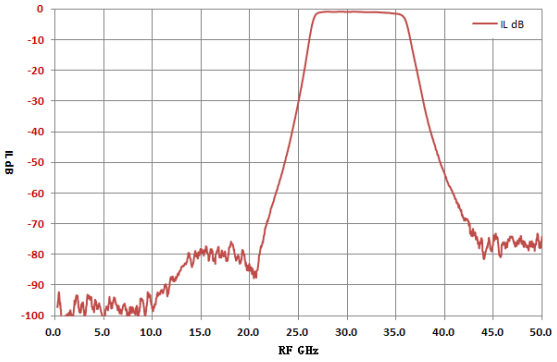
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

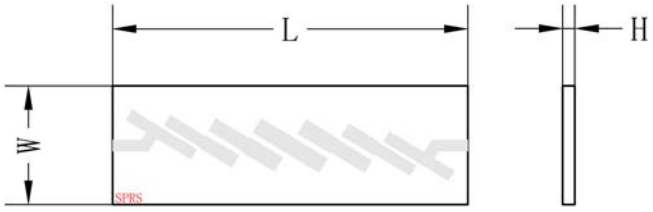
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	33.2	GHz
工作带宽	27.0-39.4	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-22.0GHz	dBc
带外抑制	40@47.0-49.0GHz	dBc

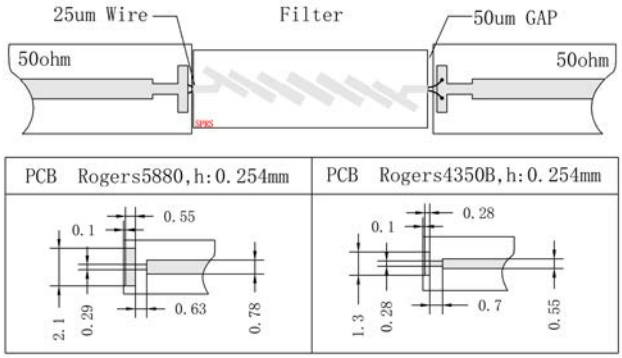
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



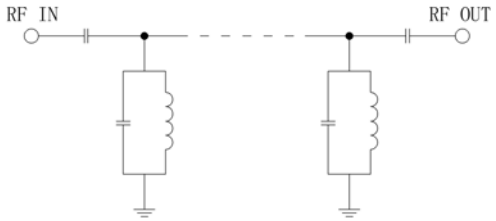
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

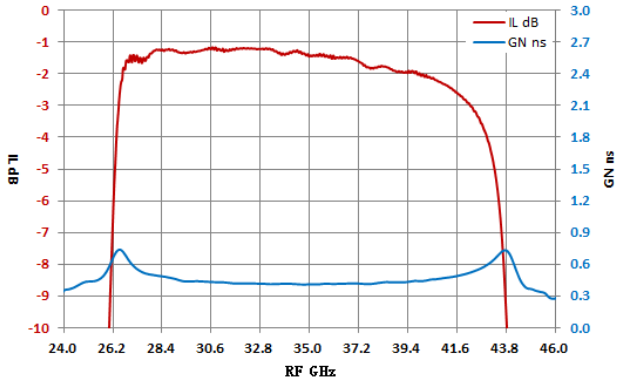
参考实物图

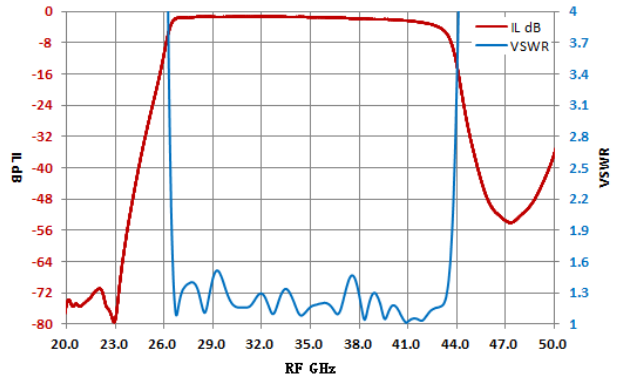


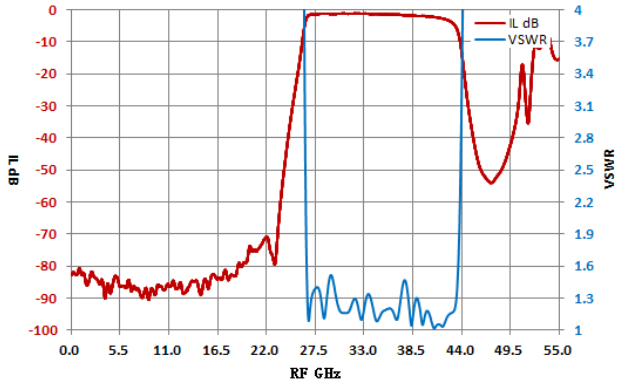
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

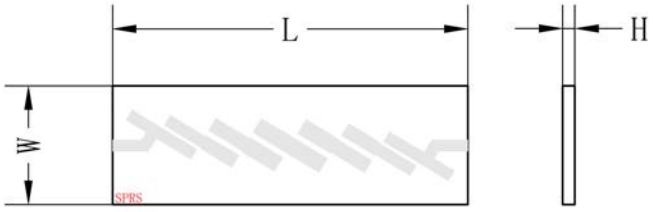
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	28.6	GHz
工作带宽	27.2-30.0	GHz
中心损耗	2.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-25.3GHz	dBc
带外抑制	40@32.7-40.0GHz	dBc

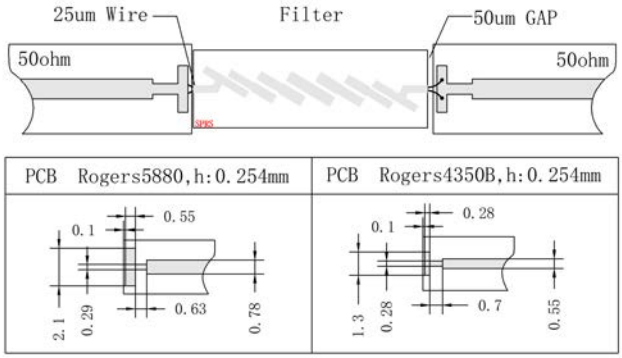
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



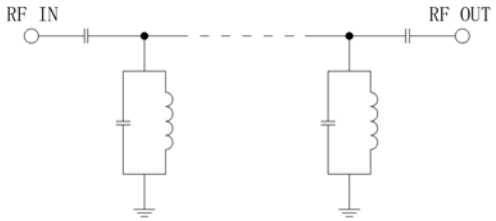
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

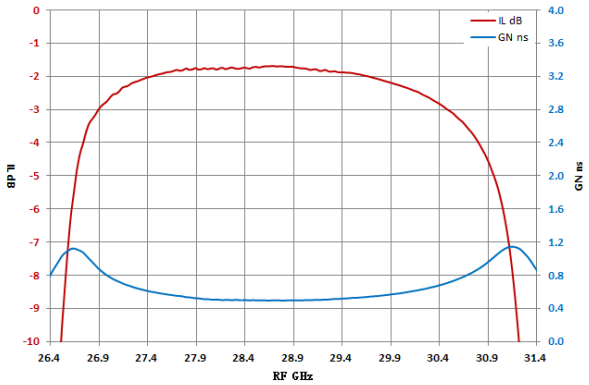
参考实物图

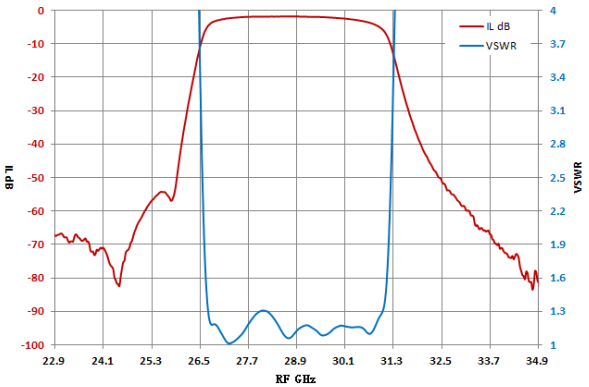


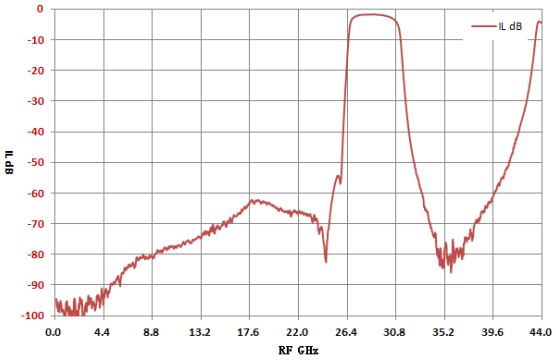
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

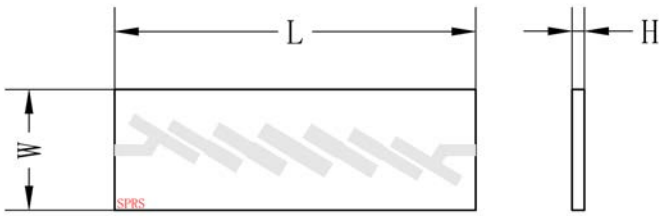
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	28.95	GHz
工作带宽	27.2-30.7	GHz
中心损耗	1.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-22.5GHz	dBc
带外抑制	40@33.0-44.0GHz	dBc

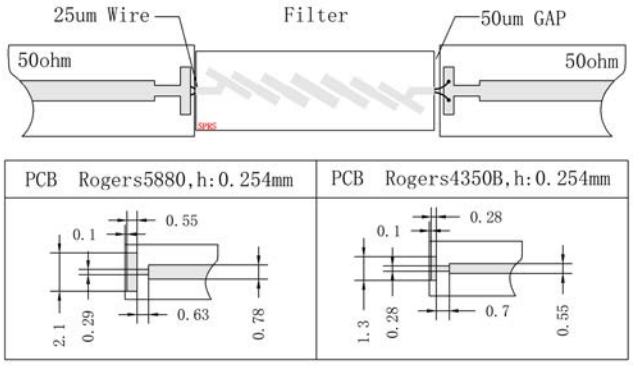
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：5.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

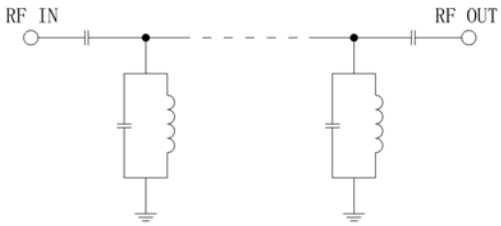
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

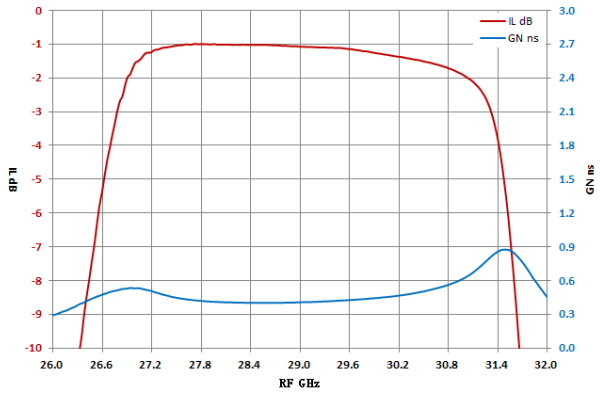
参考图

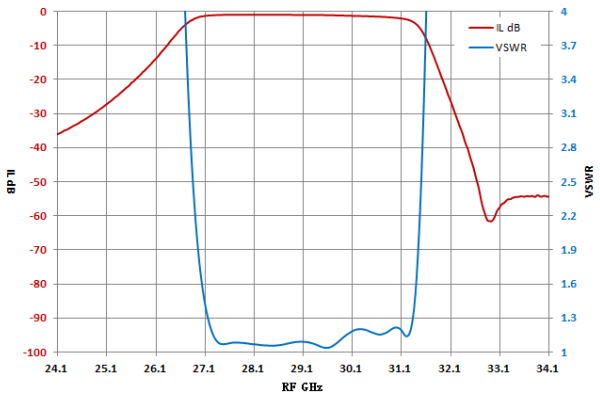


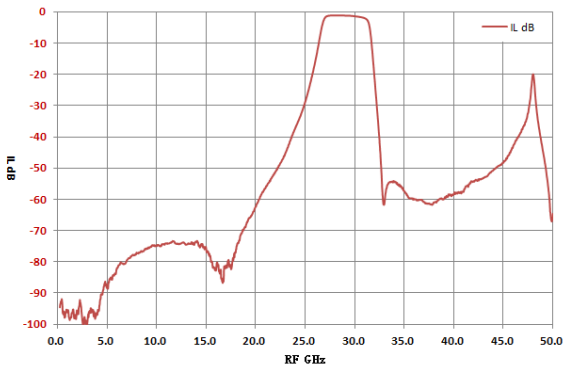
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

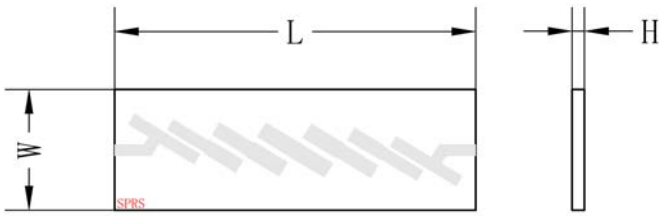
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	29.0	GHz
工作带宽	27.2-30.8	GHz
中心损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-25.5GHz	dBc
带外抑制	40@33.2-48.0GHz	dBc

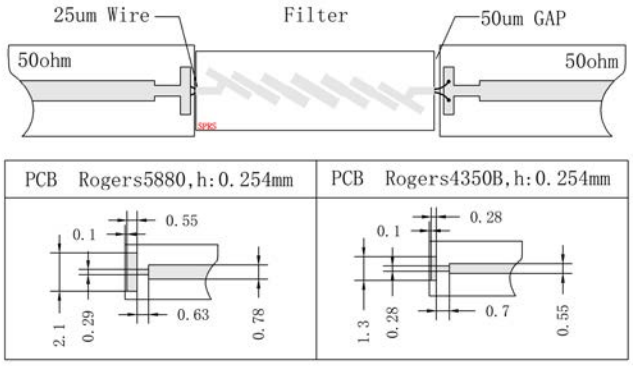
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：9.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

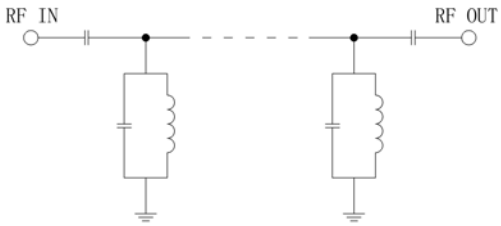
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

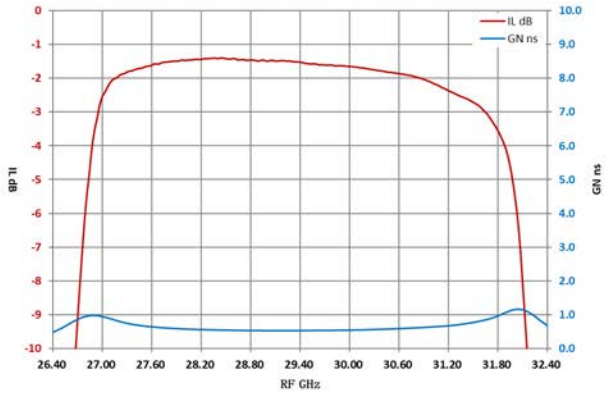
参考图

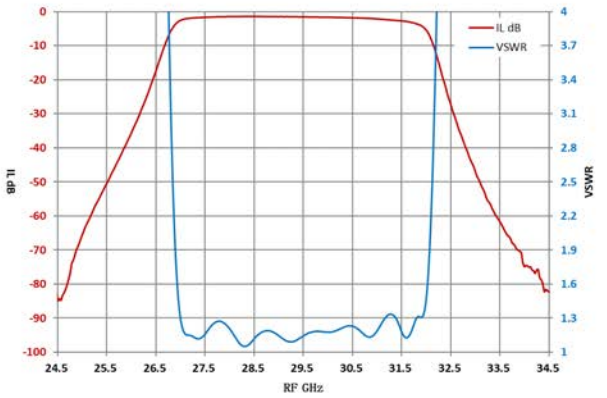


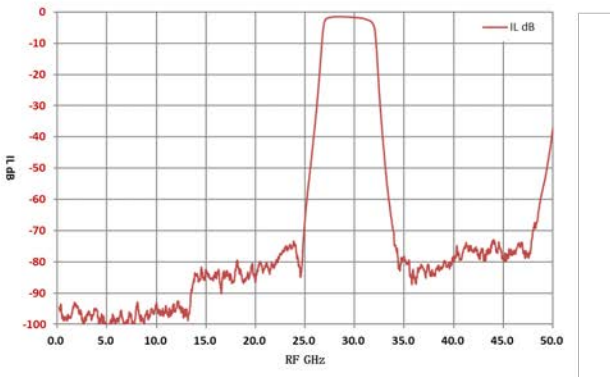
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



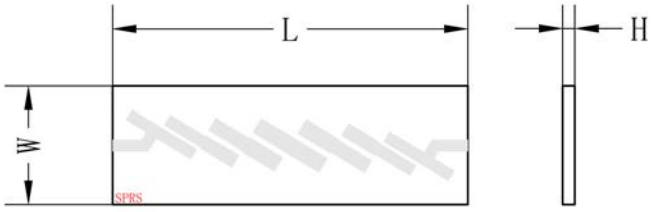
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	28.4	GHz
工作带宽	27.4-29.4	GHz
中心损耗	2.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	32@DC-25.9GHz	dBc
带外抑制	32@31.2-38.0GHz	dBc

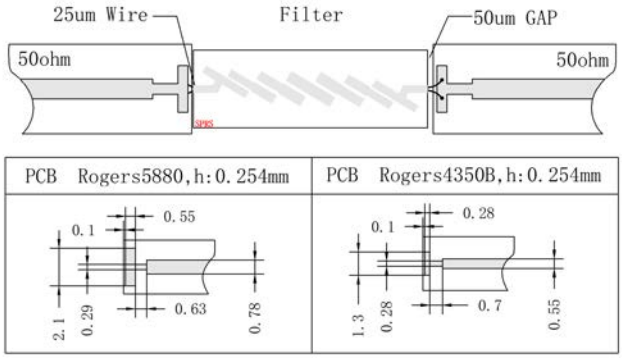
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：5.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



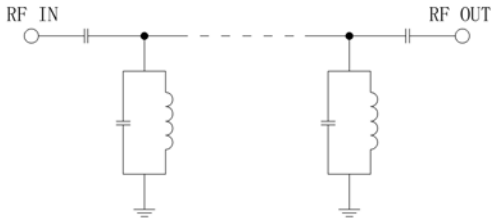
推荐装配图



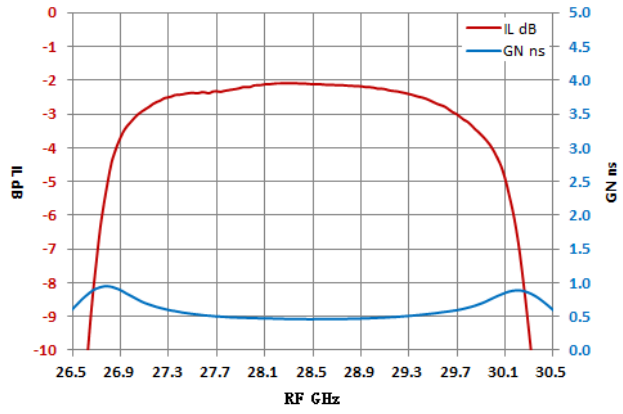
注意事项

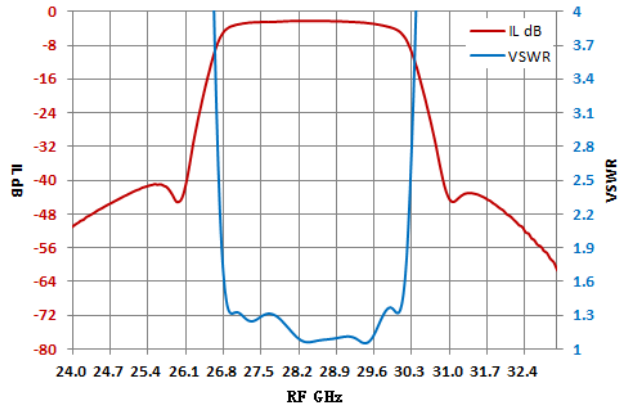
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

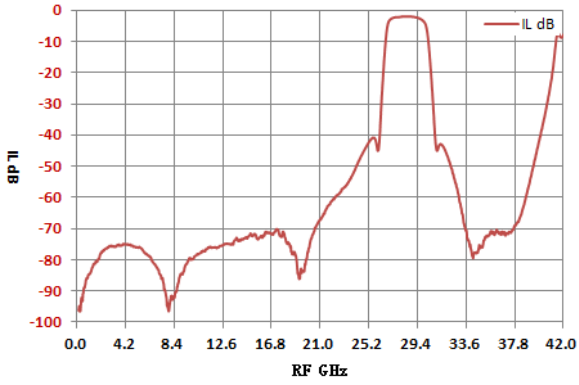
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

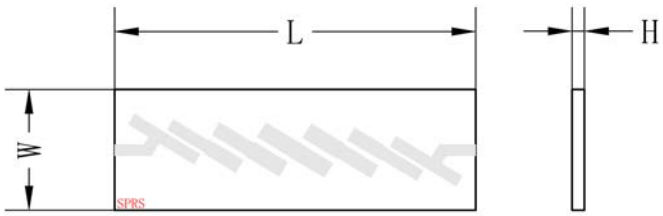
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	28.6	GHz
工作带宽	27.4-29.8	GHz
中心损耗	2.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-25.9GHz	dBc
带外抑制	40@31.9-41.0GHz	dBc

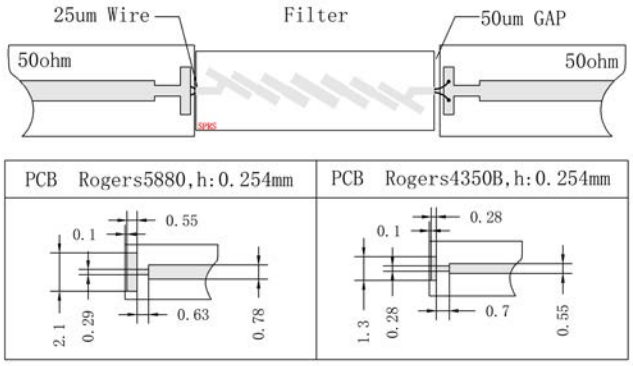
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

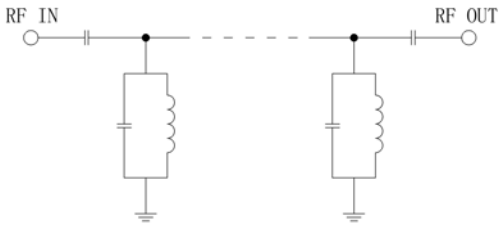
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

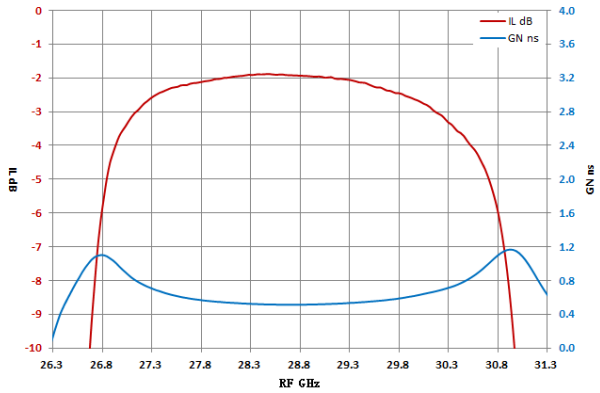
参考图

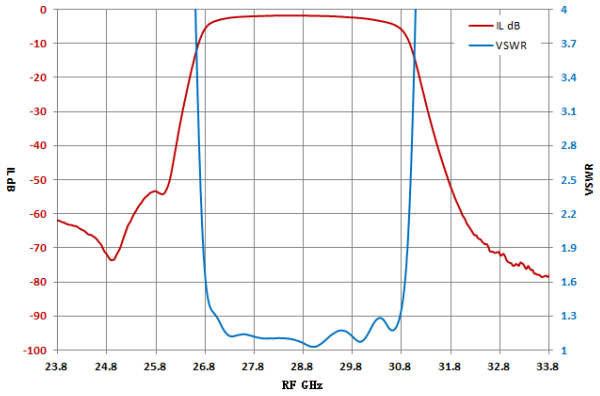


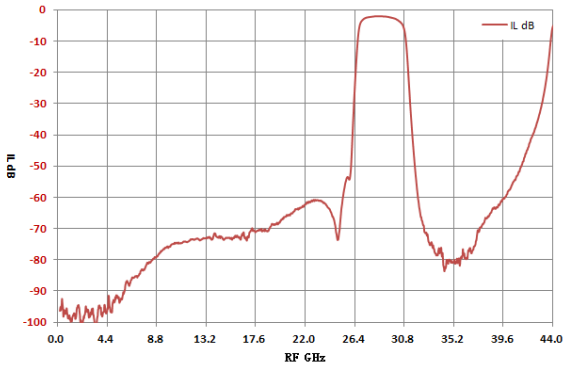
原理图



典型曲线







陶瓷滤波器 STBP286-2R4-K818

工作带宽 27.4-29.8GHz,带外抑制 40@DC-25.7GHz,40@32.3-41.0GHz

产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

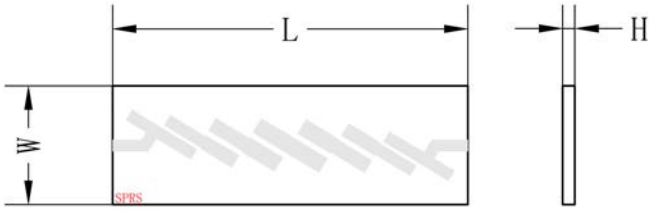
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	28.6	GHz
工作带宽	27.4-29.8	GHz
中心损耗	2.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-25.7GHz	dBc
带外抑制	40@32.2-41.0GHz	dBc

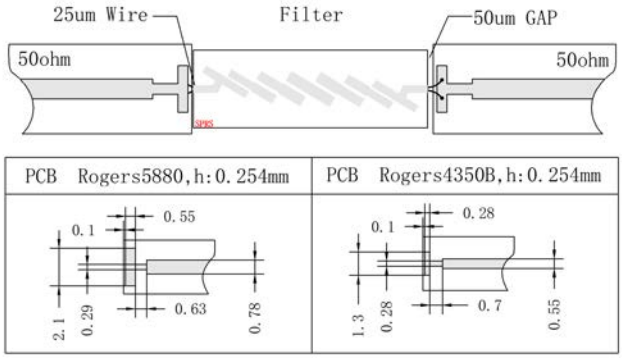
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



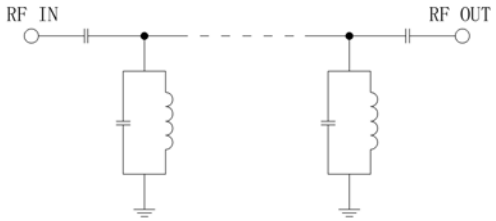
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

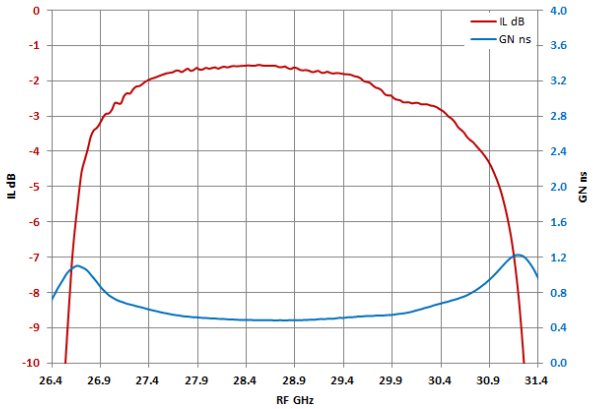
参考实物图

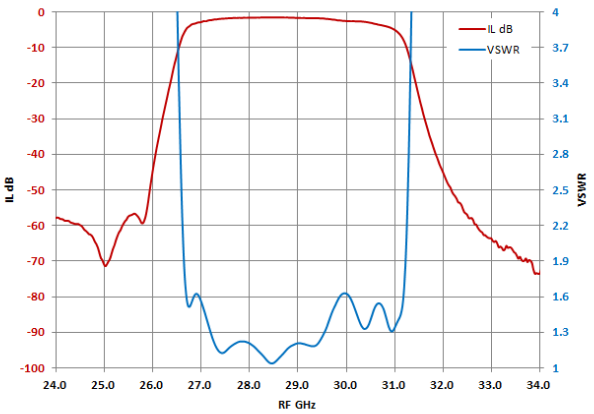


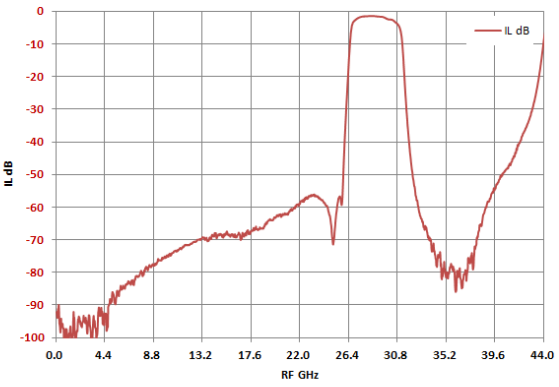
原理图



典型曲线







陶瓷滤波器 STBP338-128-M365

工作带宽 27.4-40.2GHz,带外抑制 40@DC-23.2GHz,40@46.2-50.0GHz

产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



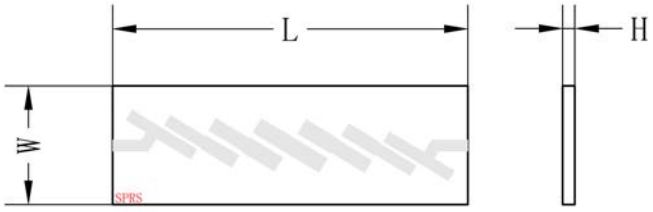
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	33.8	GHz
工作带宽	27.4-40.2	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-23.2GHz	dBc
带外抑制	40@46.2-50.0GHz	dBc

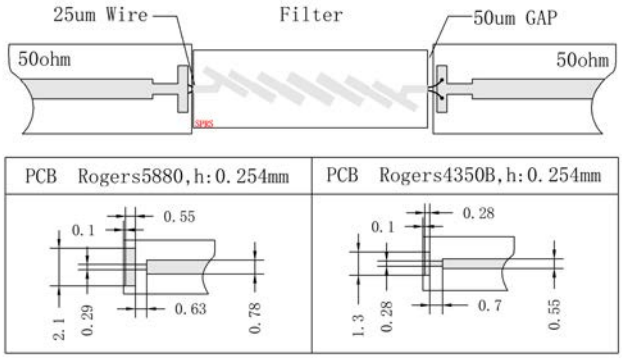
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



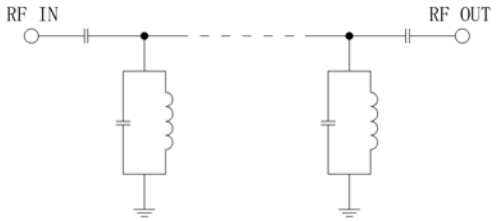
推荐装配图



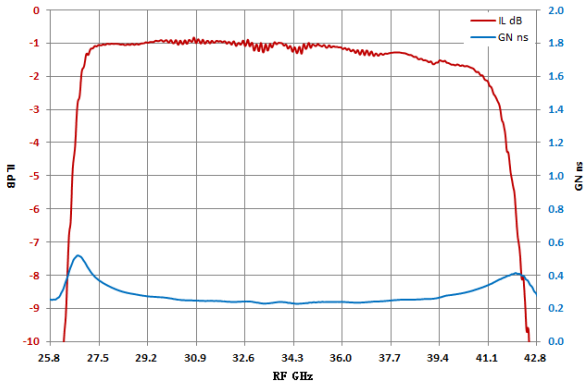
注意事项

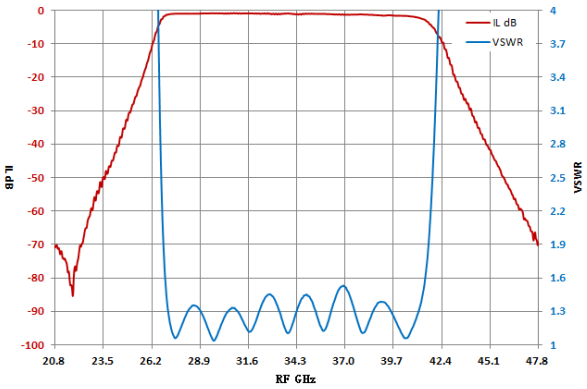
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

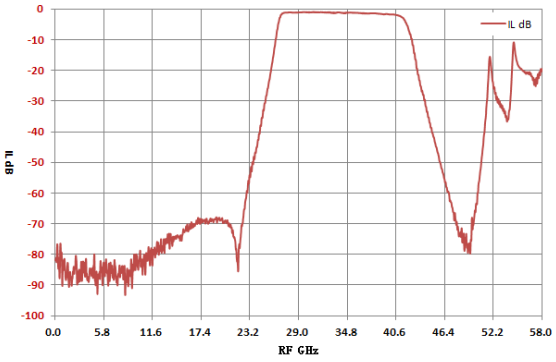
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



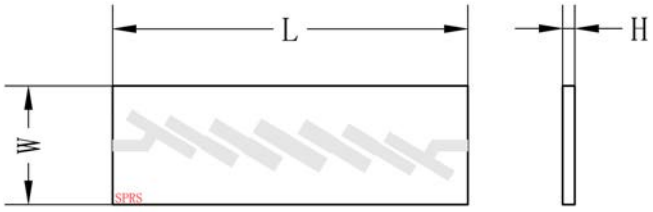
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	27.8	GHz
工作带宽	27.5-28.1	GHz
中心损耗	4.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-26.4GHz	dBc
带外抑制	40@29.4-44.0GHz	dBc

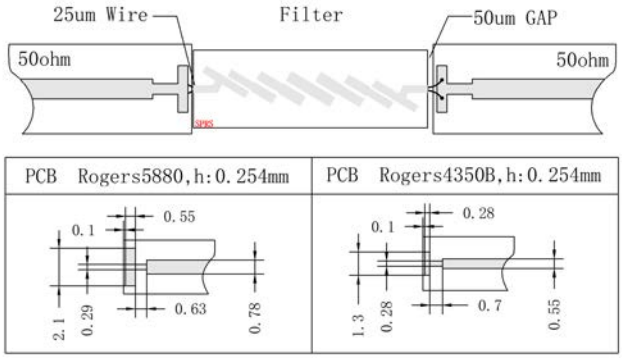
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：10.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



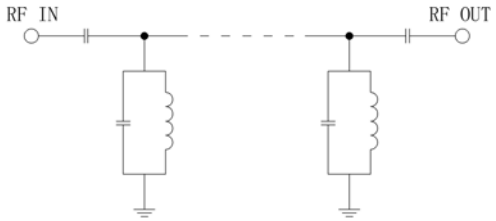
推荐装配图



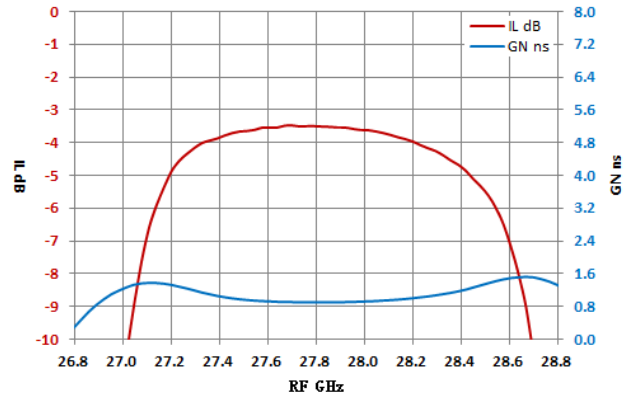
注意事项

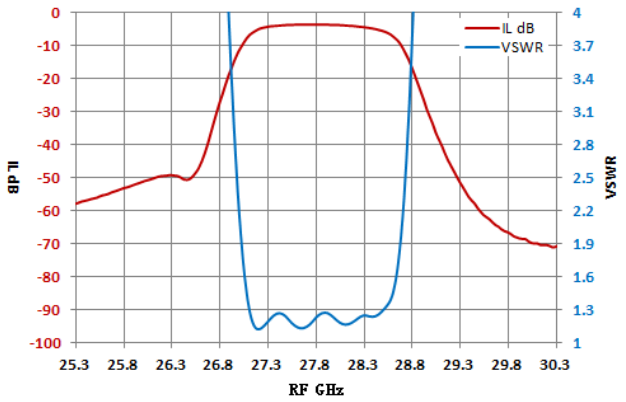
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.25mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

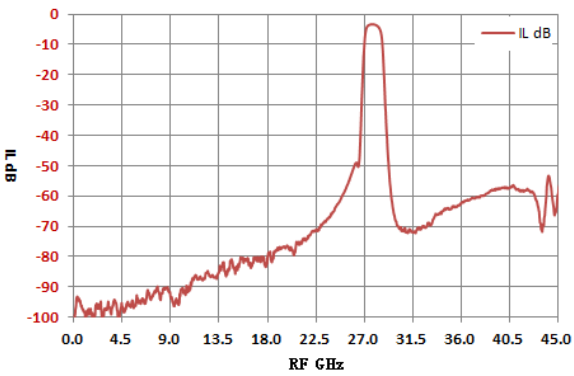
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



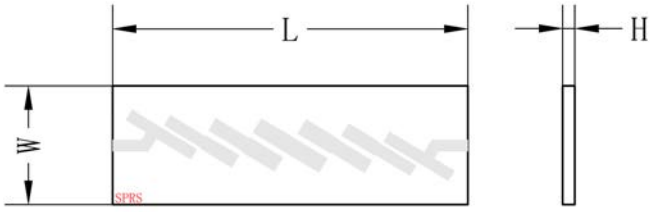
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	28.2	GHz
工作带宽	27.5-28.9	GHz
中心损耗	3.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-25.9GHz	dBc
带外抑制	25@30.3GHz	dBc

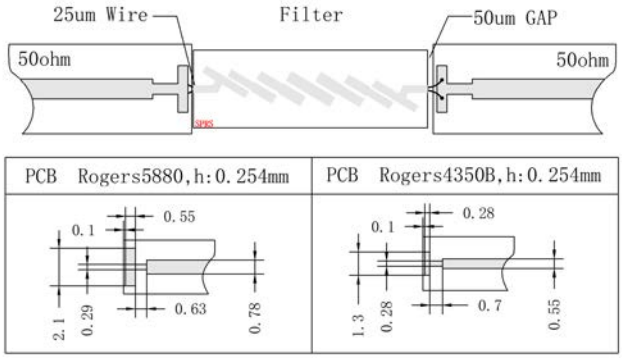
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



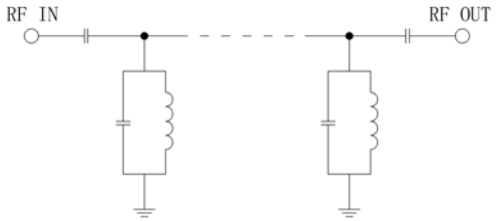
推荐装配图



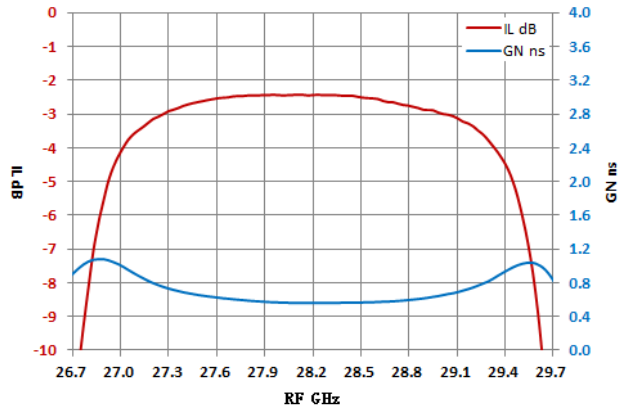
注意事项

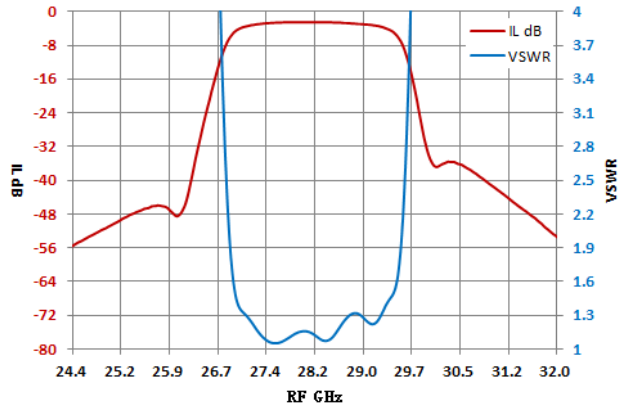
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

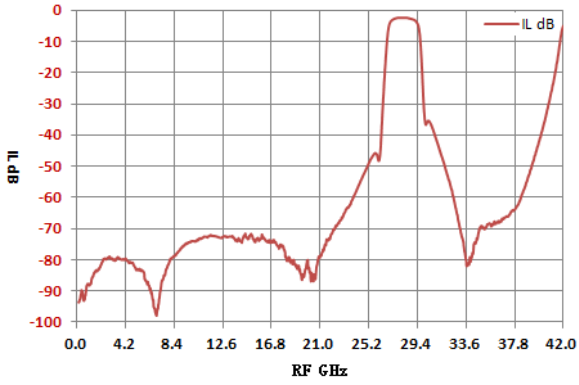
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



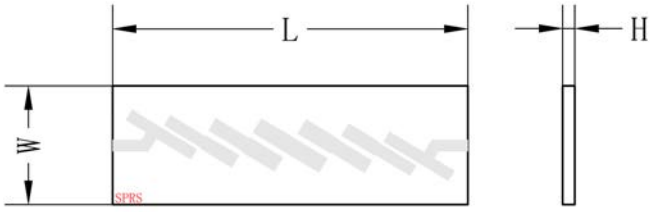
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	28.3	GHz
工作带宽	27.5-29.1	GHz
中心损耗	2.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	33@DC-26.2GHz	dBc
带外抑制	33@30.6GHz	dBc

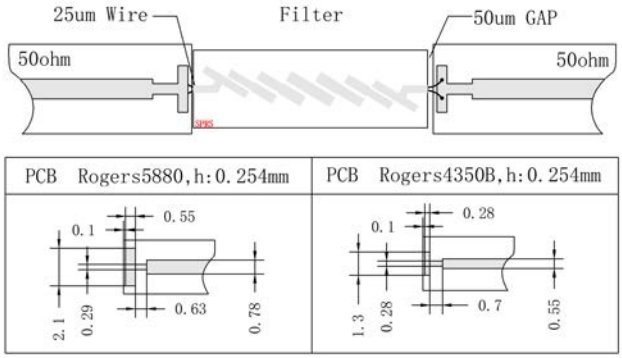
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：5.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



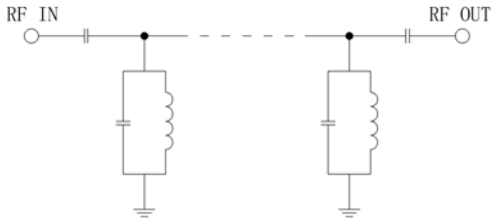
推荐装配图



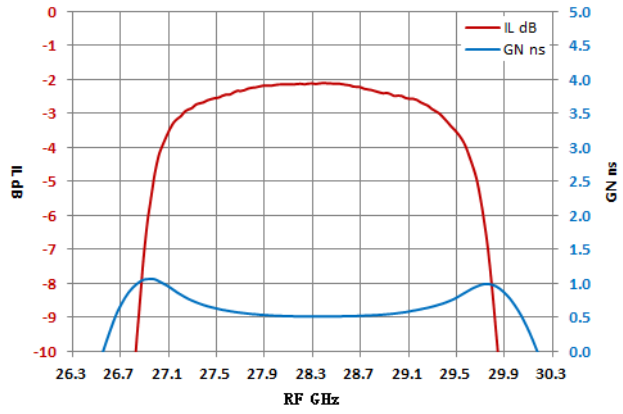
注意事项

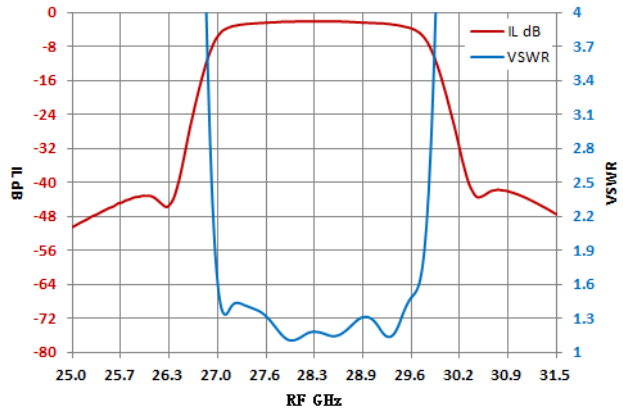
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

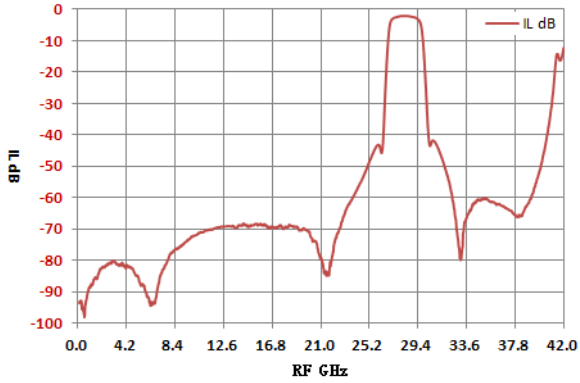
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

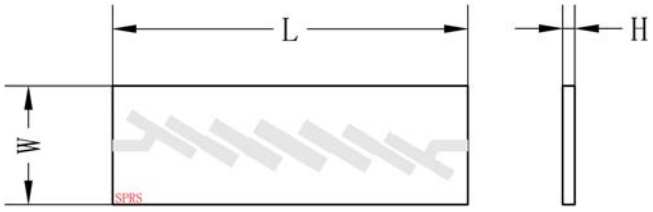
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	29.7	GHz
工作带宽	27.5-31.9	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-23.6GHz	dBc
带外抑制	40@34.8-43.0GHz	dBc

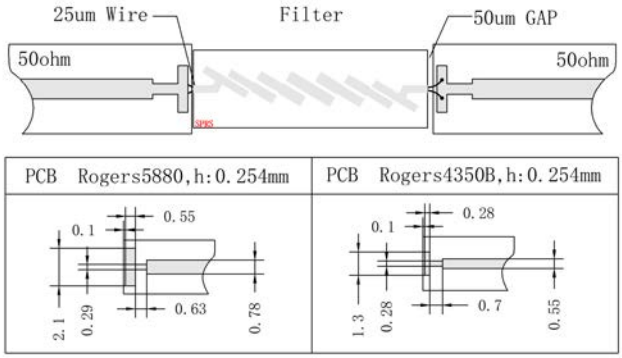
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



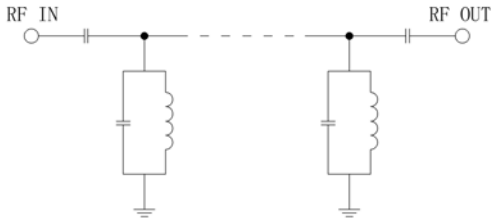
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.74mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

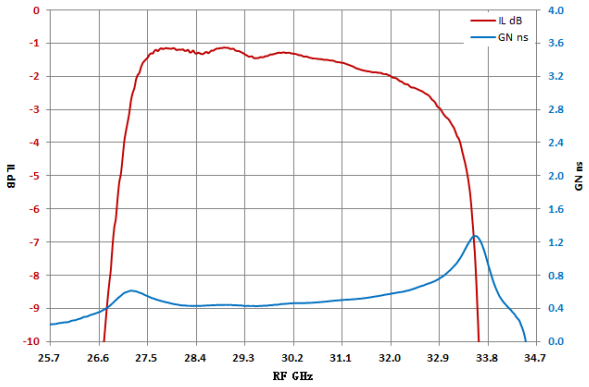
参考实物图

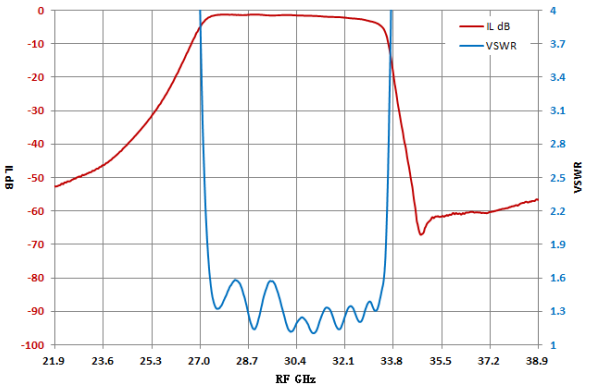


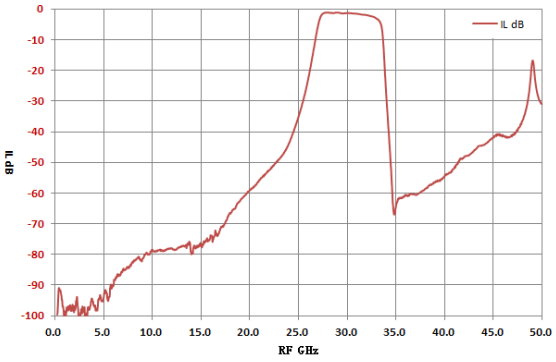
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

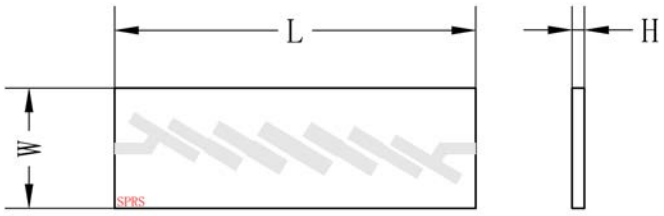
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	30.0	GHz
工作带宽	27.5-32.5	GHz
中心损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.8:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	60@DC-24.8GHz	dBc
带外抑制	50@35.6-42.0GHz	dBc

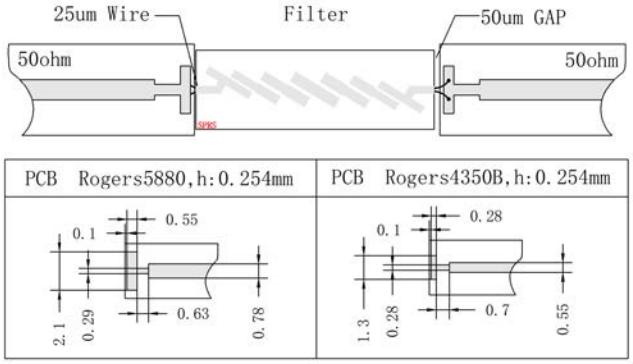
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：6.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

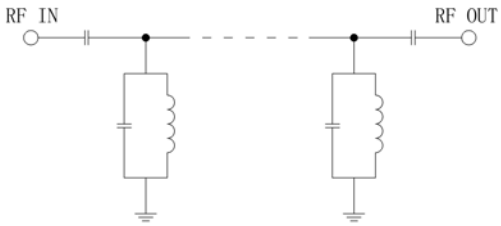
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

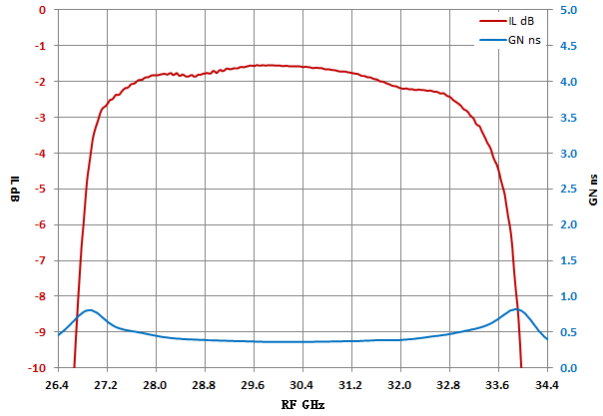
参考图

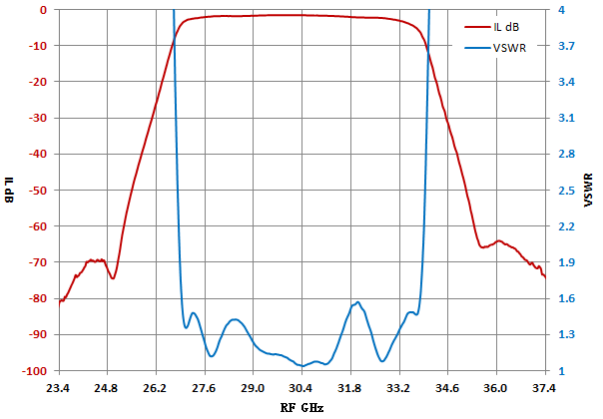


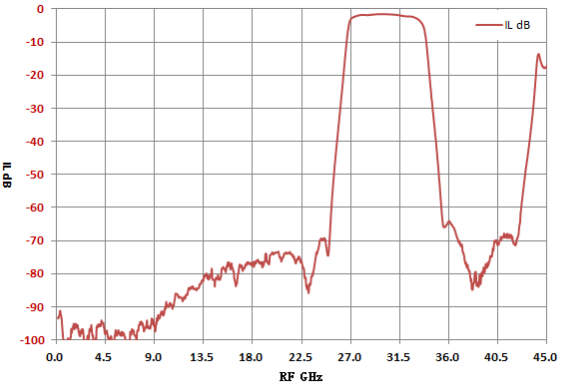
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

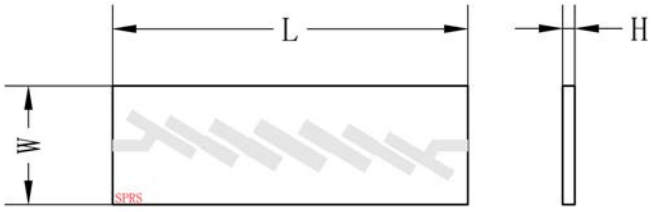
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	29.8	GHz
工作带宽	27.6-32.0	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-25.4GHz	dBc
带外抑制	40@34.5-40.0GHz	dBc

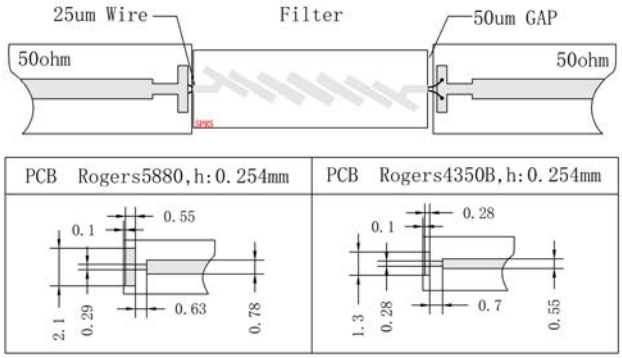
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



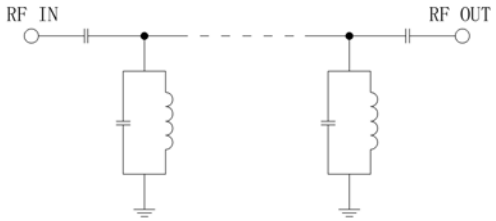
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

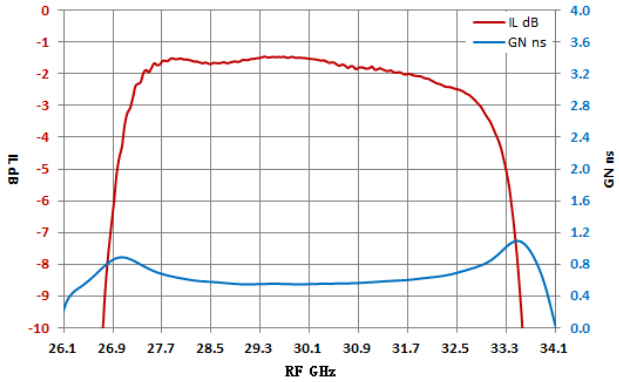
参考实物图

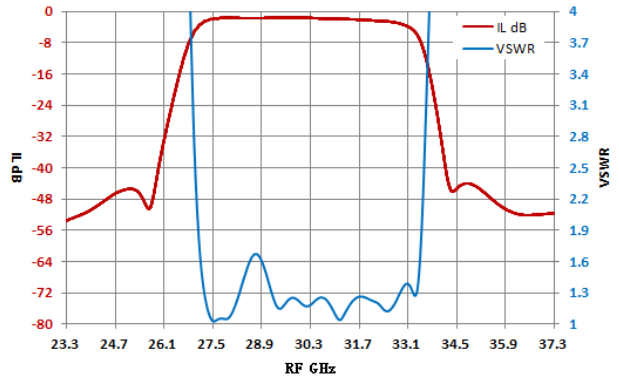


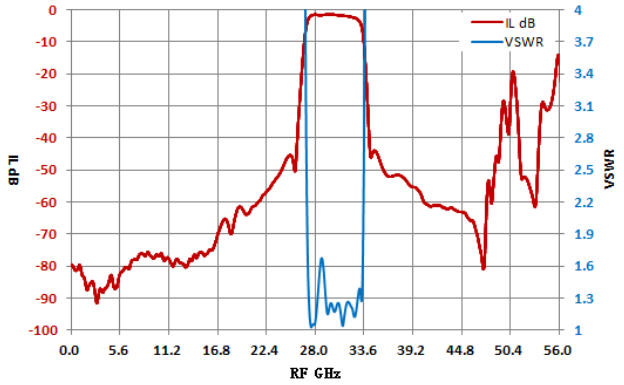
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

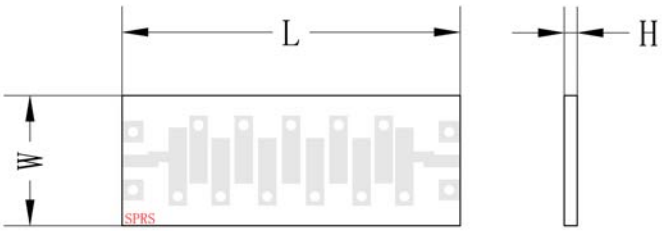
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	30.8	GHz
工作带宽	27.6-34.0	GHz
中心损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-25.0GHz	dBc
带外抑制	50@37.0-49.0GHz	dBc

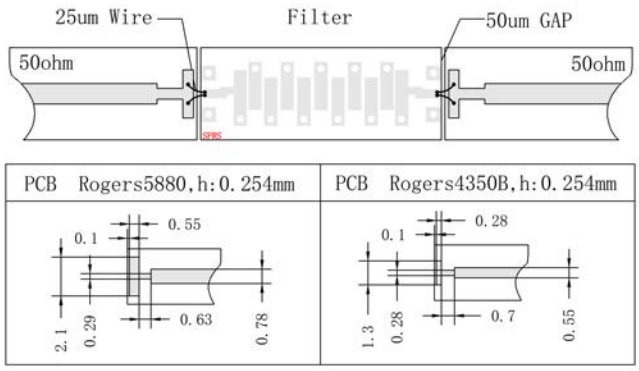
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

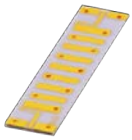
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

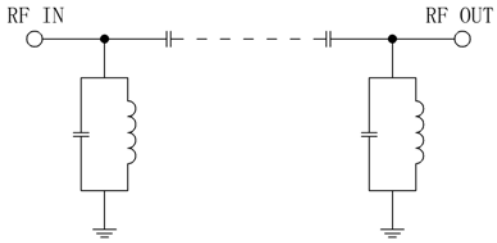
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

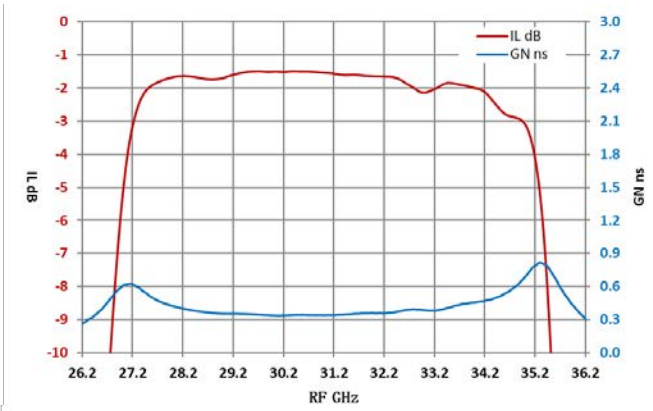
参考图

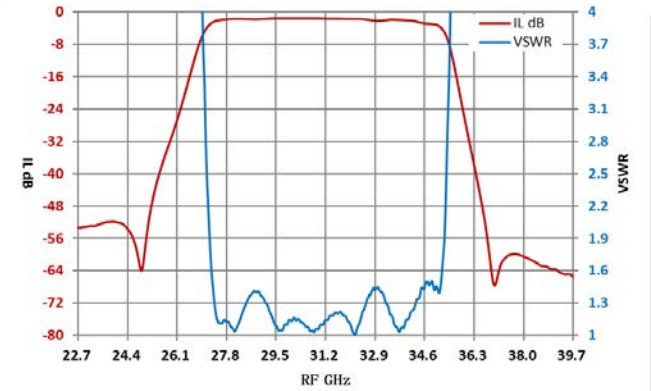


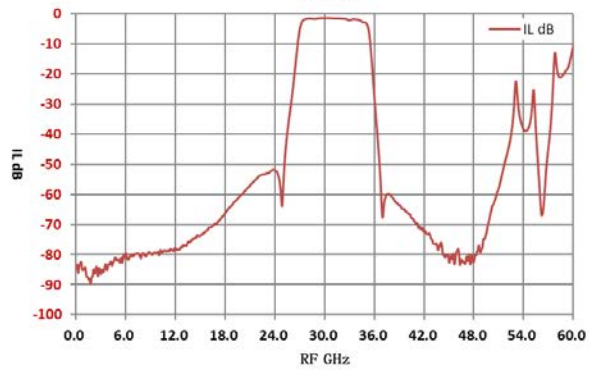
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



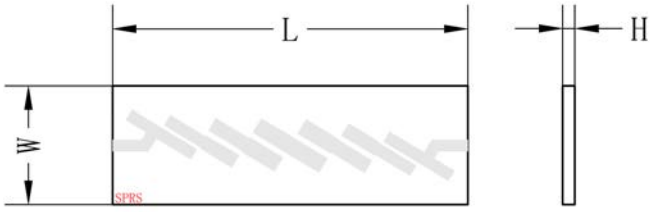
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	28.2	GHz
工作带宽	27.7-28.7	GHz
中心损耗	4.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-26.4GHz	dBc
带外抑制	40@30.2-38.0GHz	dBc

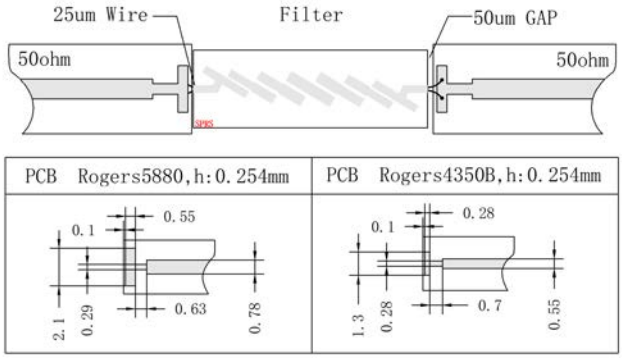
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：10.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



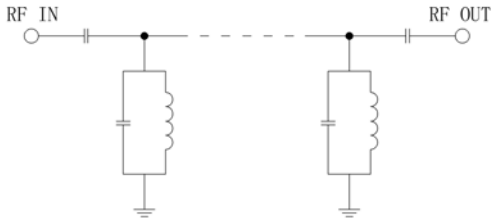
推荐装配图



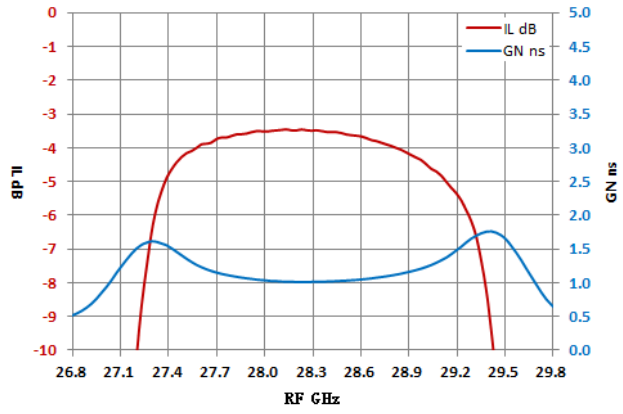
注意事项

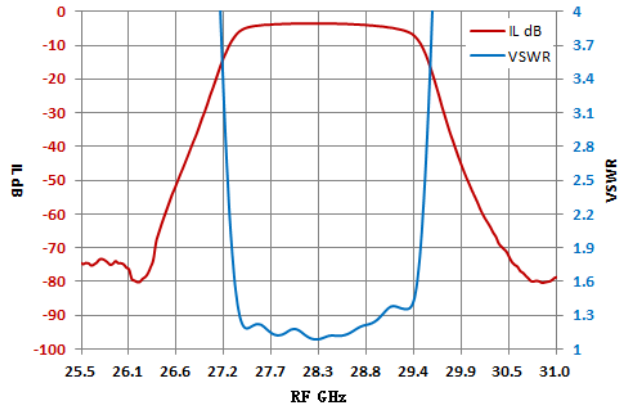
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

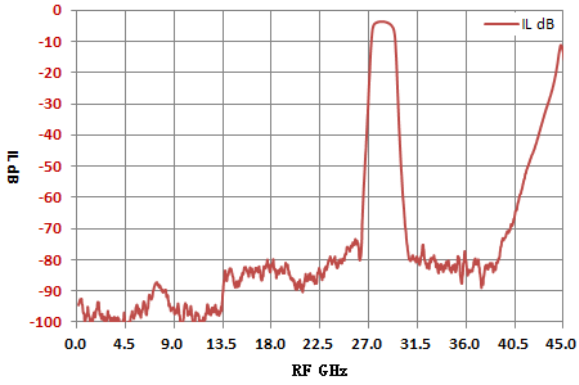
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

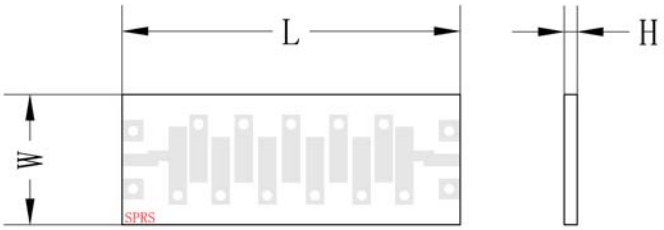
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	28.8	GHz
工作带宽	27.8-29.8	GHz
中心损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	45@DC-25.8GHz	dBc
带外抑制	45@31.6-42.0GHz	dBc

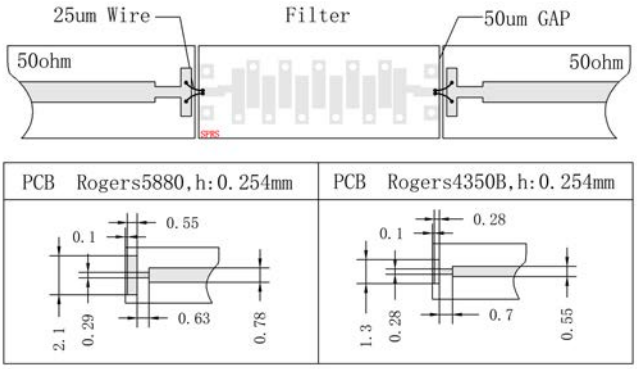
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：6.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

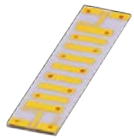
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

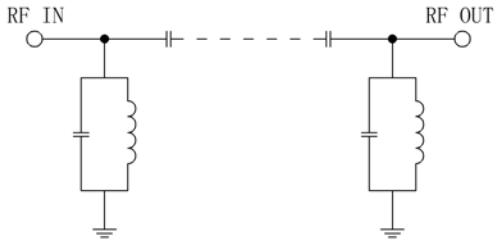
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

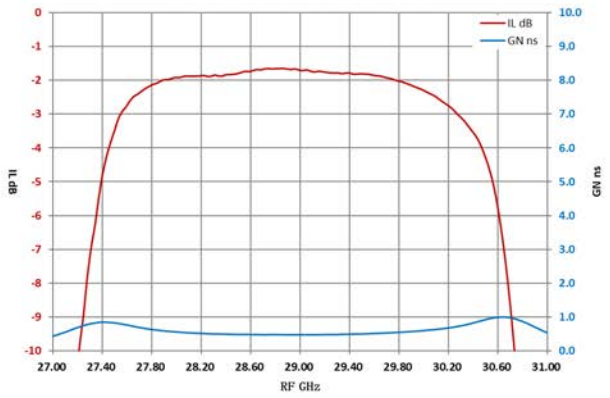
参考图

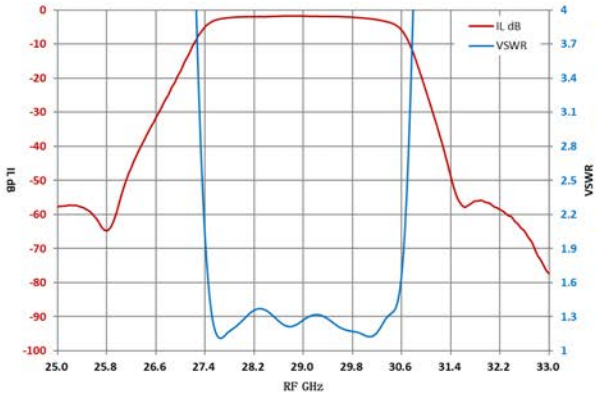


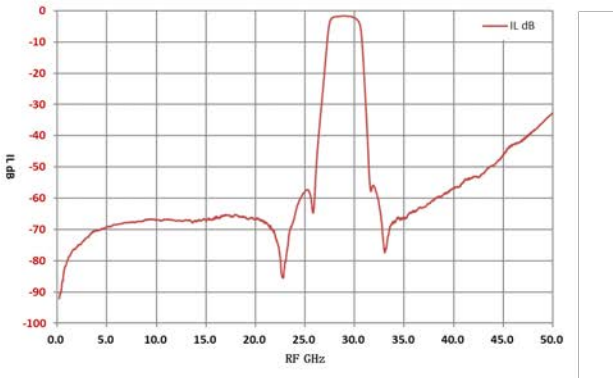
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



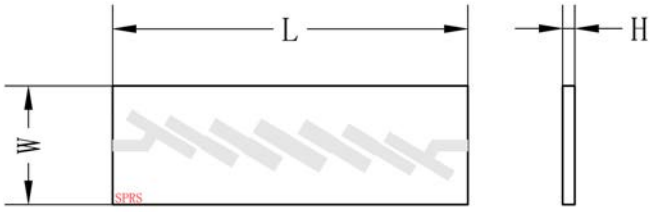
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	30.1	GHz
工作带宽	27.8-32.4	GHz
中心损耗	2.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-25.5GHz	dBc
带外抑制	40@35.0-41.0GHz	dBc

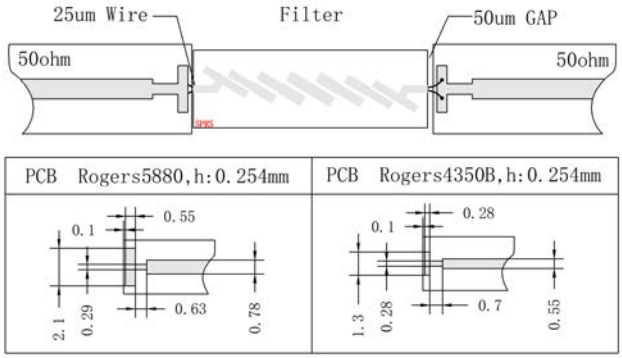
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



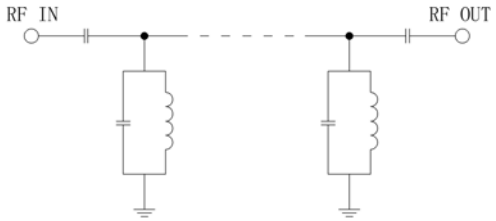
推荐装配图



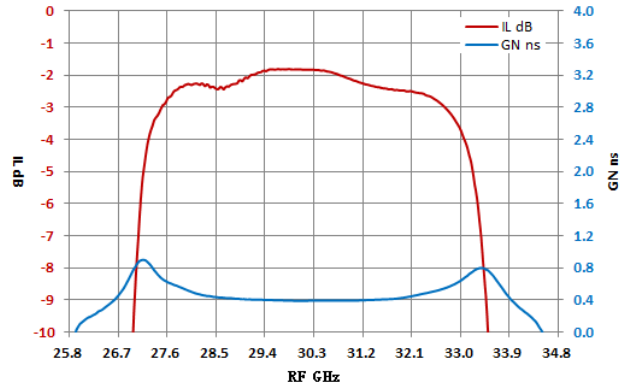
注意事项

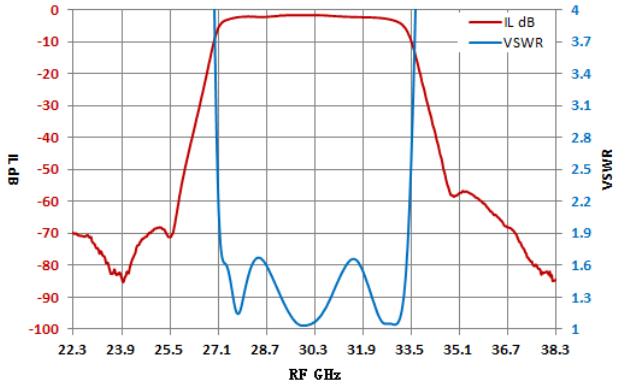
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

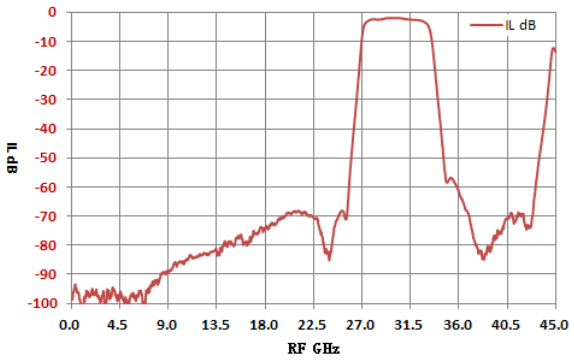
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

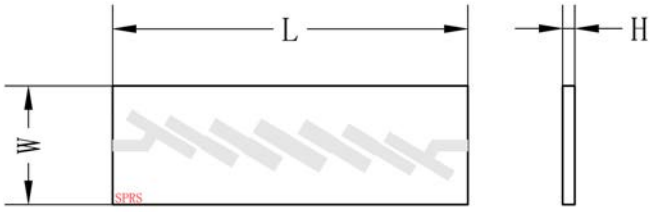
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	31.0	GHz
工作带宽	27.8-34.2	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-22.8GHz	dBc
带外抑制	40@38.1-51.0GHz	dBc

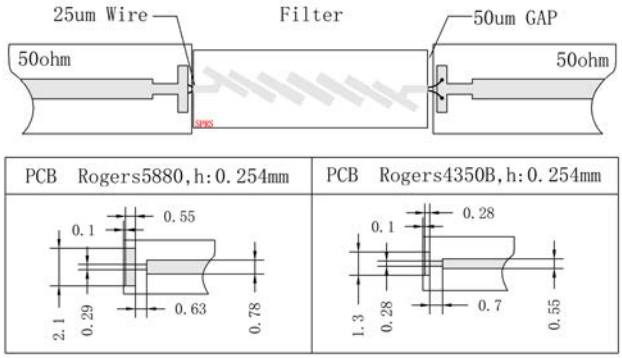
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



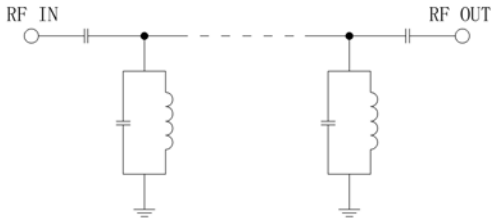
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

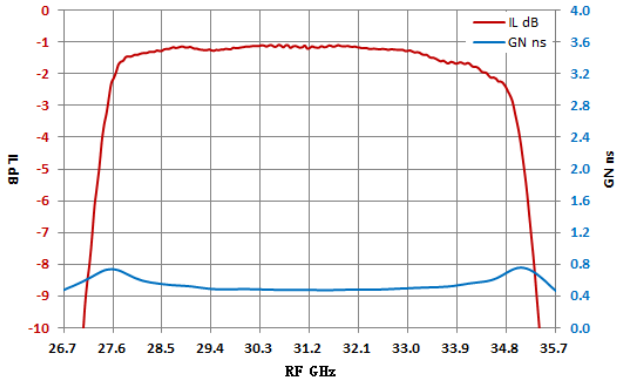
参考实物图

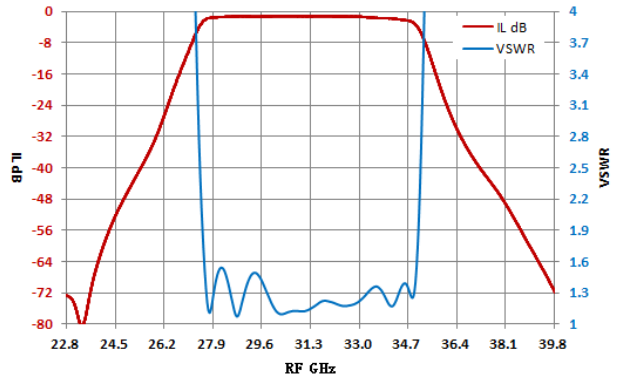


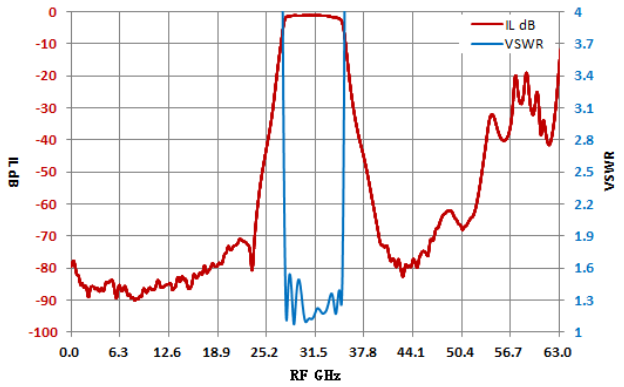
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



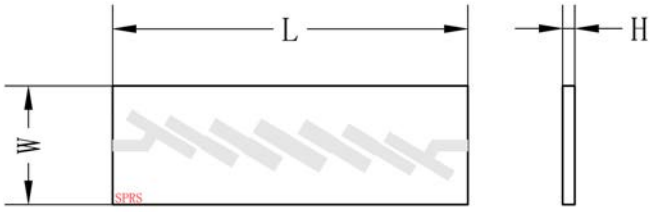
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	31.5	GHz
工作带宽	27.8-35.2	GHz
中心损耗	1.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-24.5GHz	dBc
带外抑制	40@39.5-50.0GHz	dBc

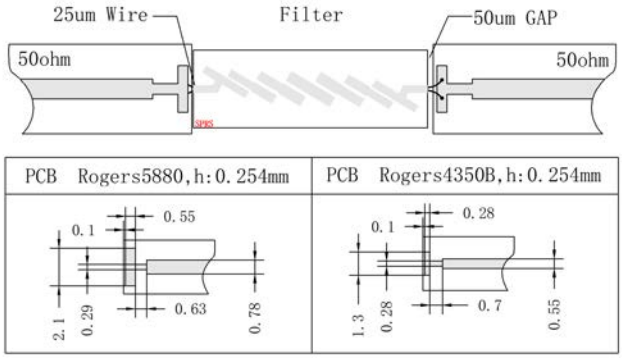
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



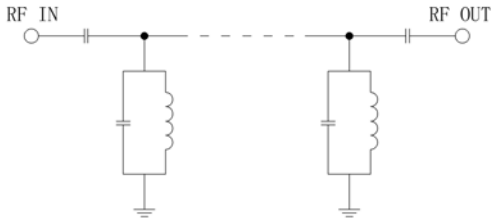
推荐装配图



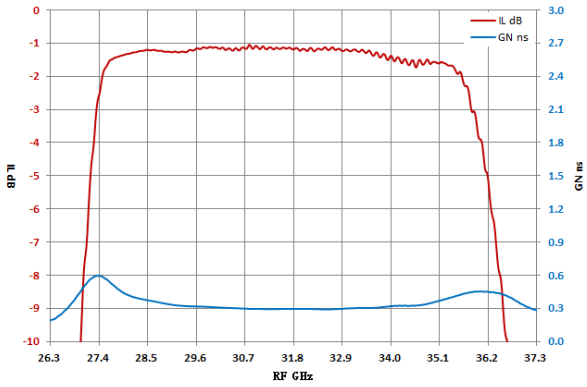
注意事项

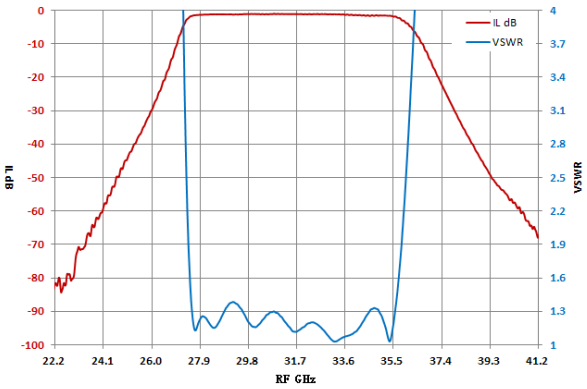
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

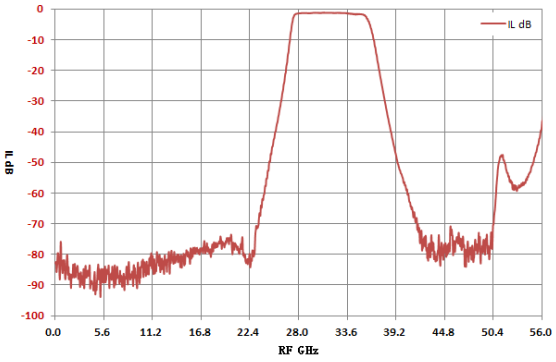
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

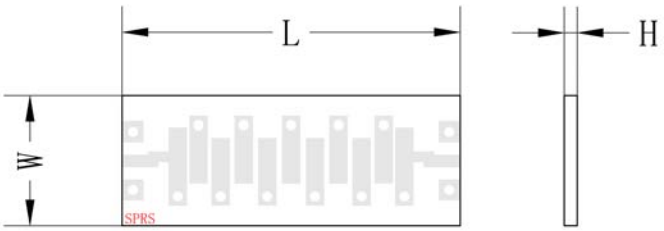
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	31.7	GHz
工作带宽	27.9-35.5	GHz
中心损耗	1.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-25.3GHz	dBc
带外抑制	40@39.0-48.0GHz	dBc

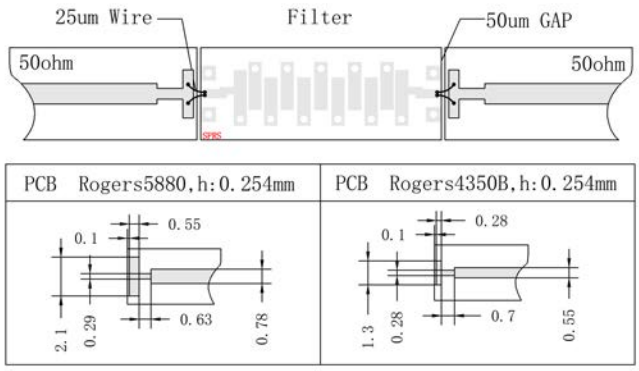
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

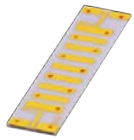
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

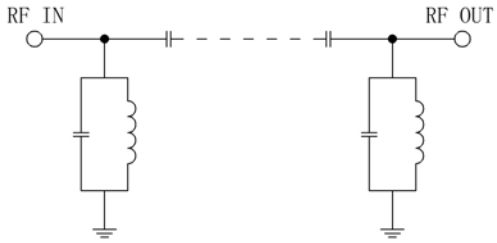
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

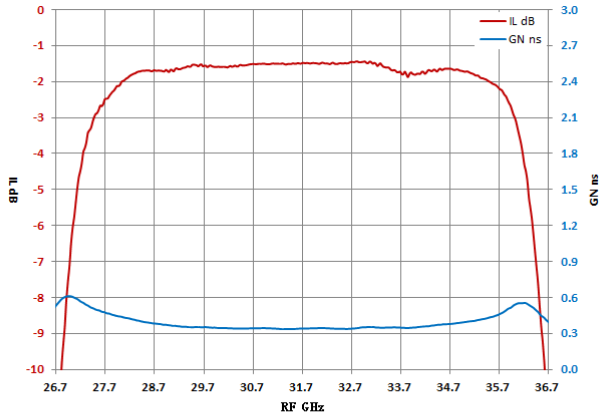
参考图

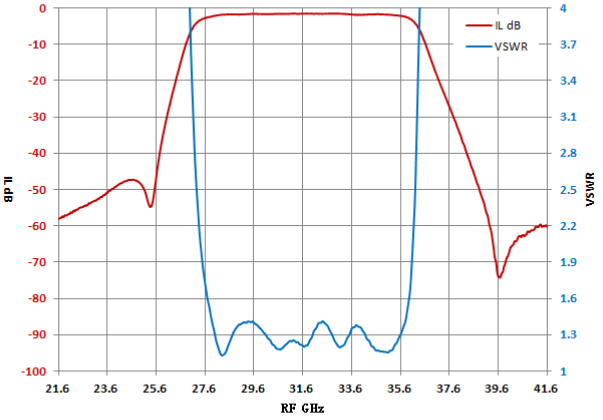


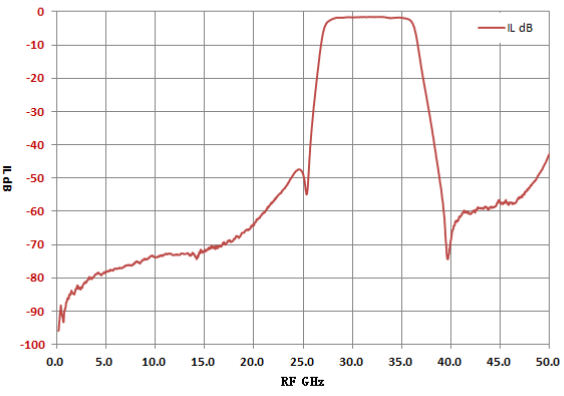
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



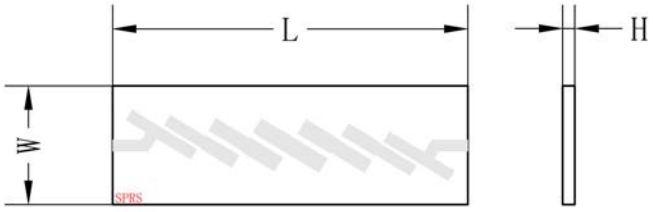
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	30.3	GHz
工作带宽	28.0-32.6	GHz
中心损耗	1.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-25.0GHz	dBc
带外抑制	40@35.6-45.0GHz	dBc

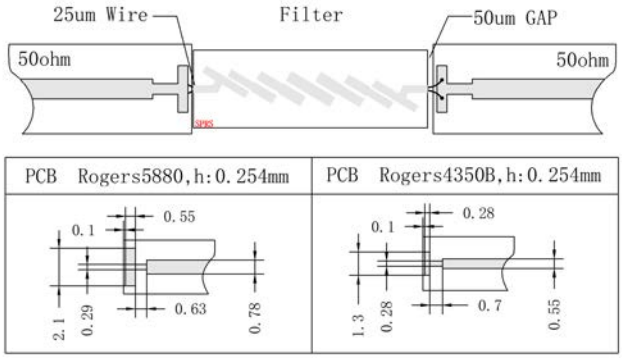
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



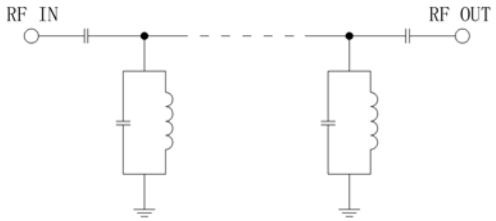
推荐装配图



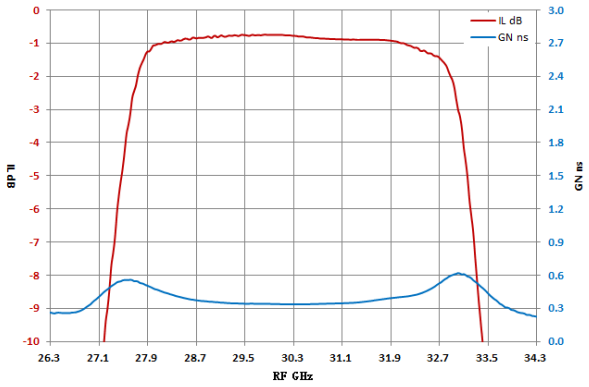
注意事项

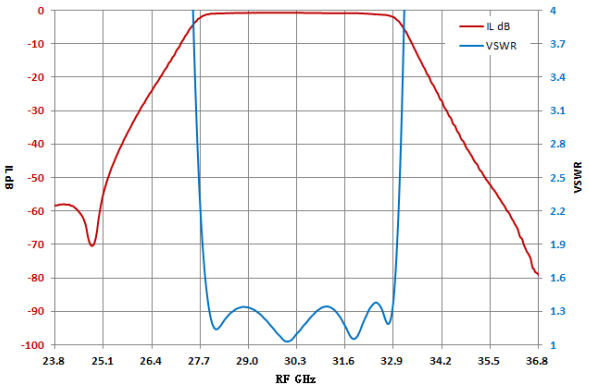
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

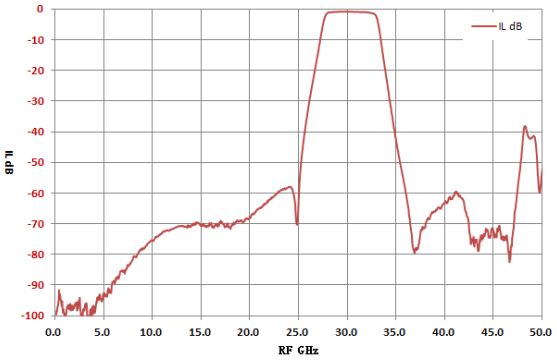
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

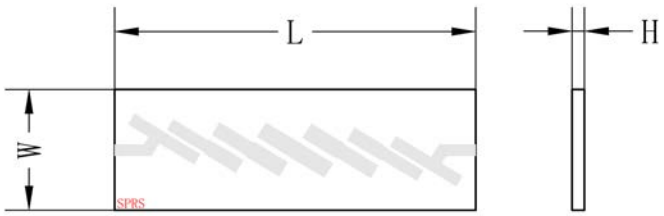
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	31.0	GHz
工作带宽	28.0-34.0	GHz
中心损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-25.2GHz	dBc
带外抑制	40@38.2-46.0GHz	dBc

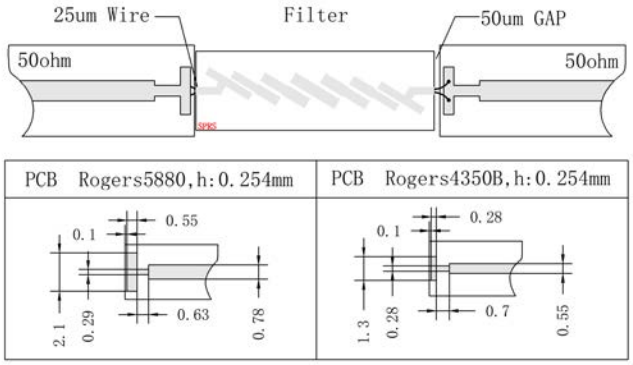
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

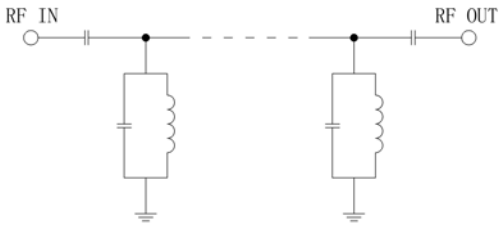
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

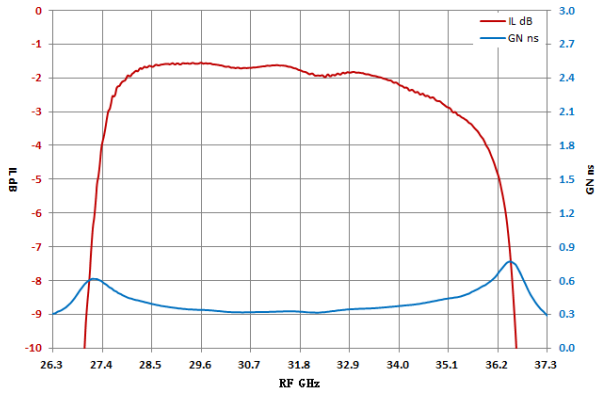
参考图

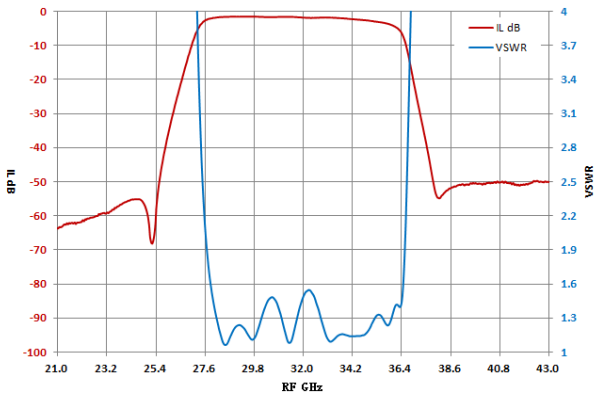


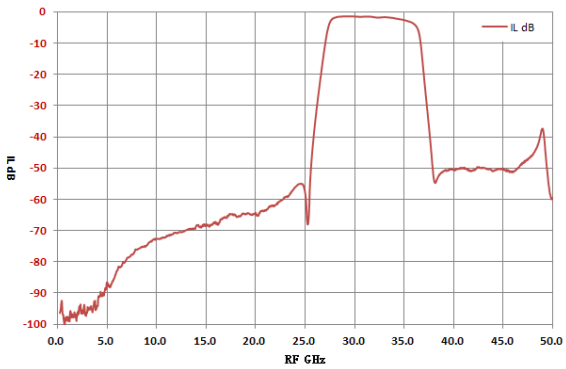
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



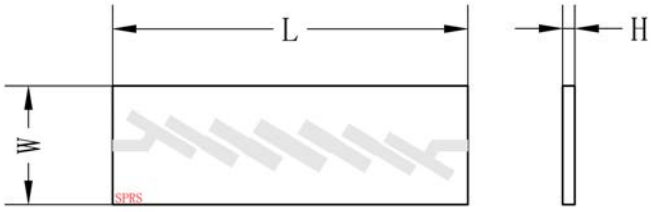
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	28.9	GHz
工作带宽	28.2-29.6	GHz
中心损耗	3.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-25.8GHz	dBc
带外抑制	40@31.8-51.0GHz	dBc

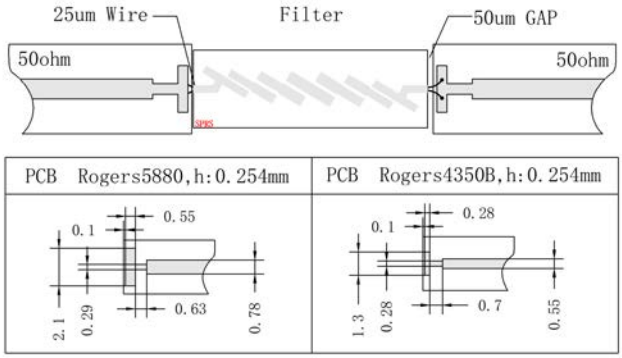
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



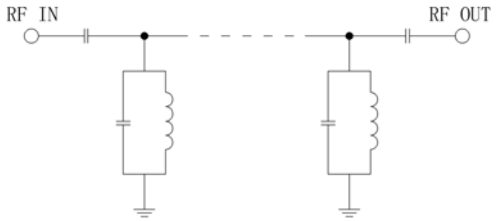
推荐装配图



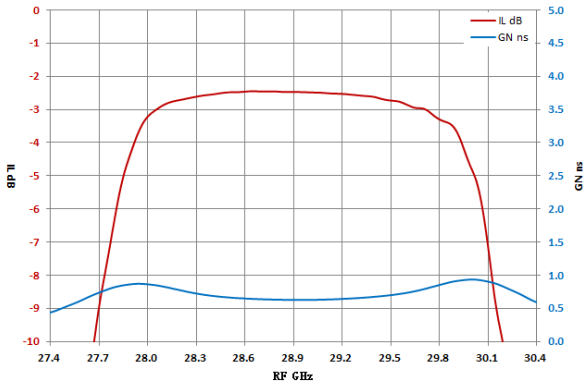
注意事项

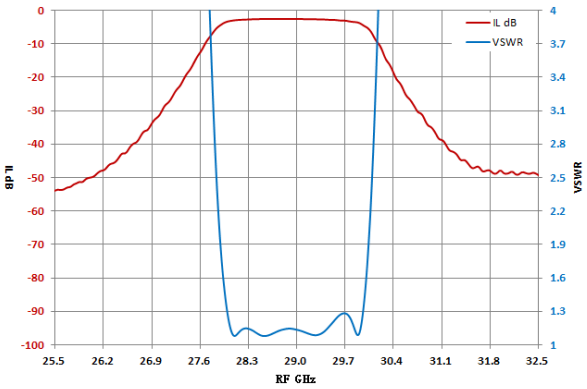
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

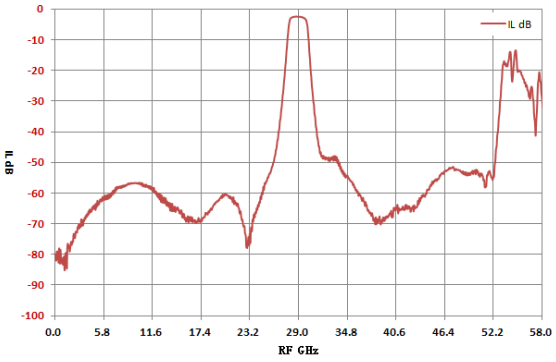
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

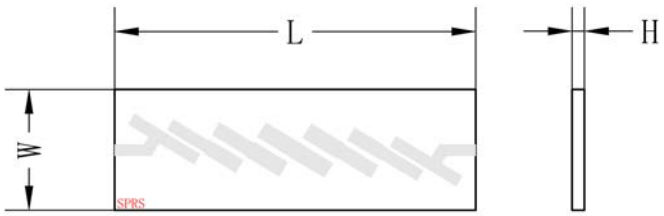
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	30.2	GHz
工作带宽	28.2-32.2	GHz
中心损耗	1.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-25.6GHz	dBc
带外抑制	30@34.8-46.0GHz	dBc

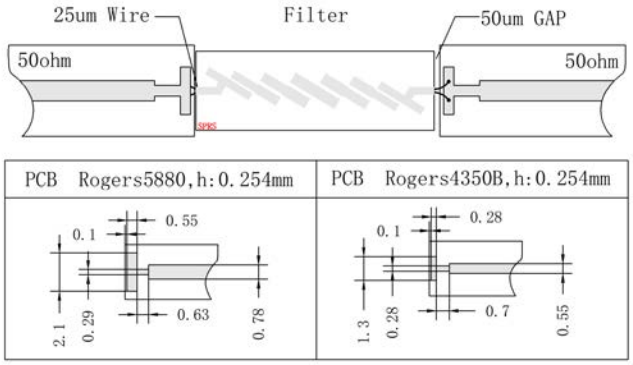
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：5.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

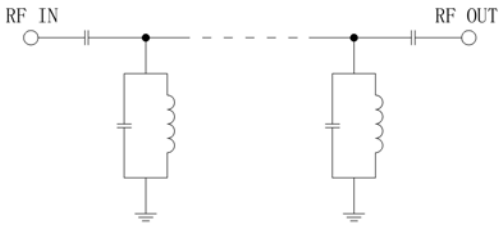
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

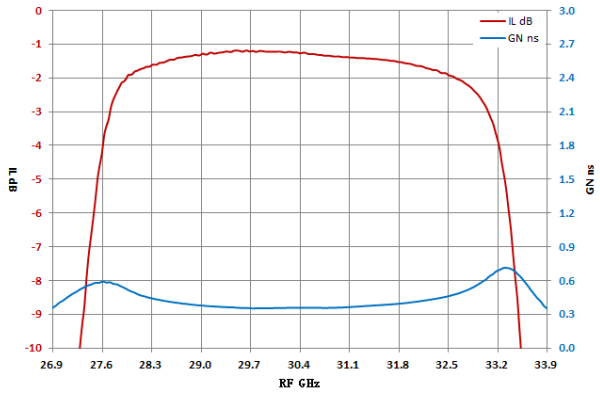
参考图

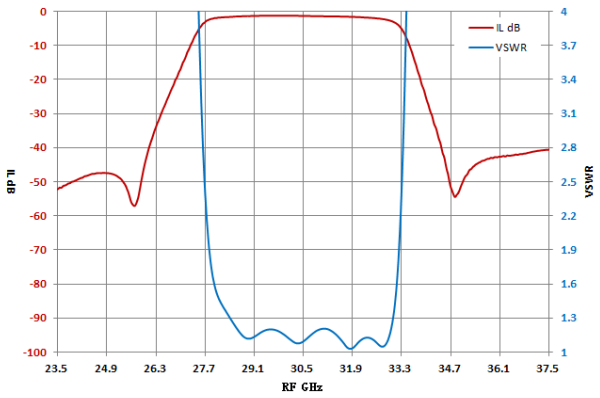


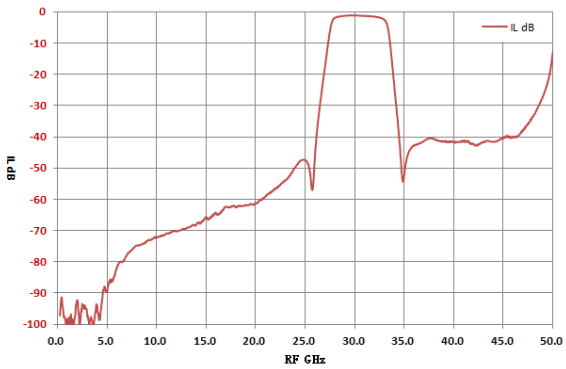
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

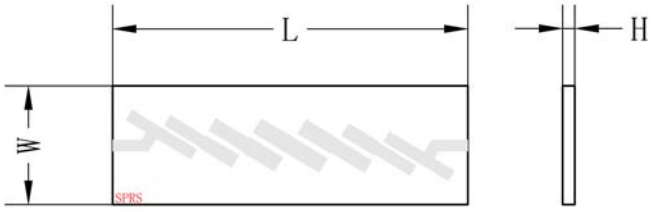
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	30.15	GHz
工作带宽	28.3-32.0	GHz
中心损耗	1.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-24.6GHz	dBc
带外抑制	40@34.5-37.0GHz	dBc

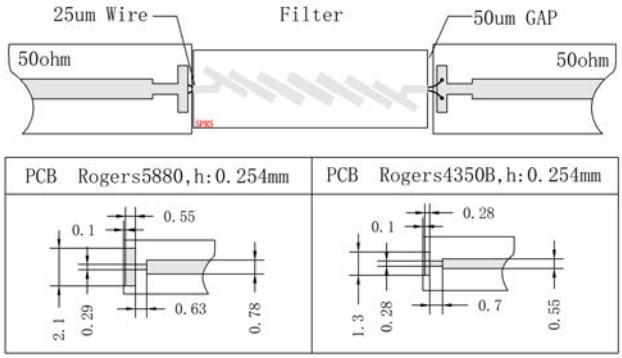
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



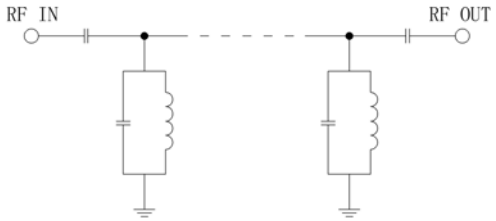
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

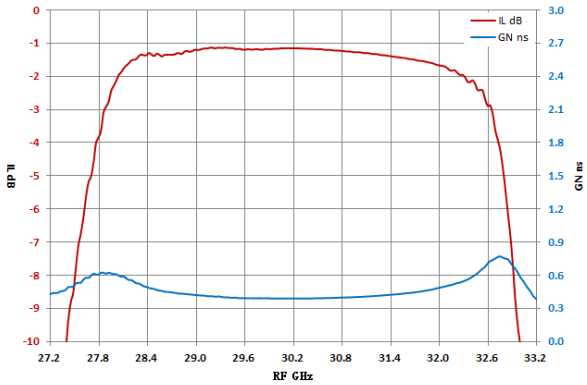
参考实物图

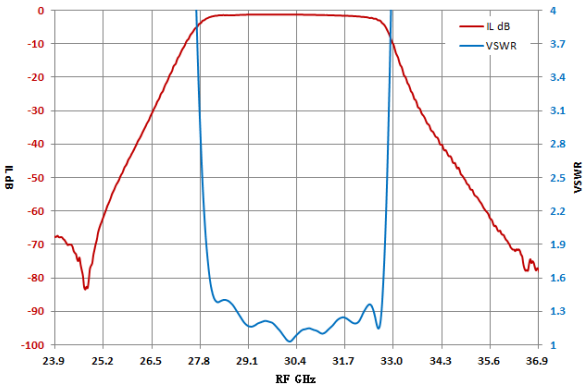


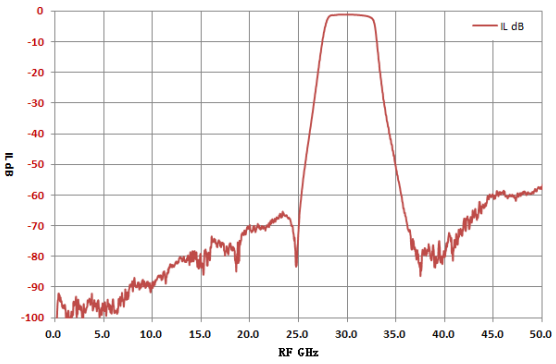
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



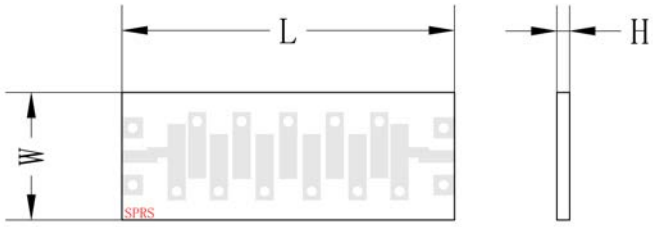
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	30.7	GHz
工作带宽	28.3-33.0	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-25.8GHz	dBc
带外抑制	40@35.3-48.0GHz	dBc

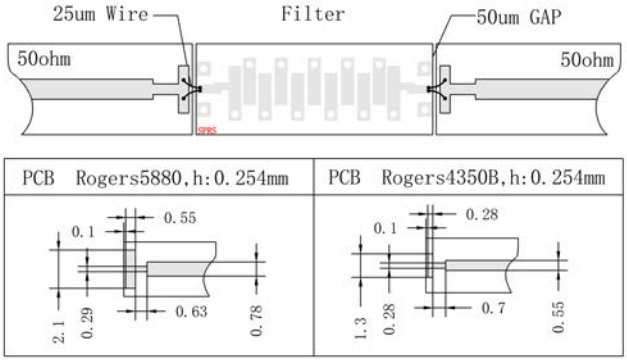
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



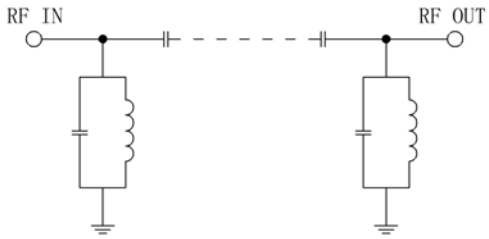
推荐装配图



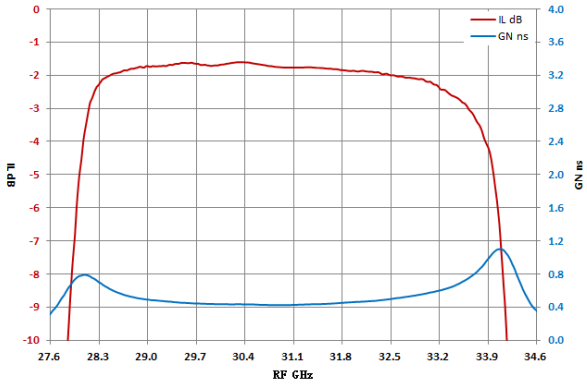
注意事项

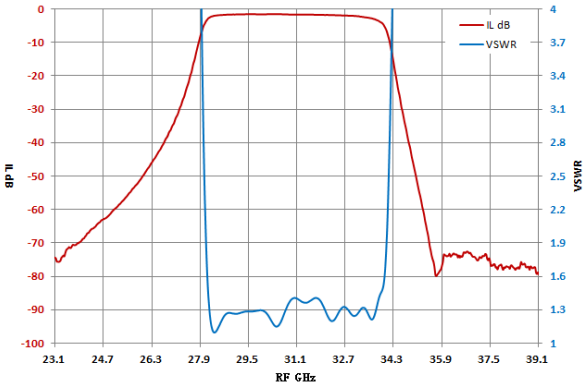
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

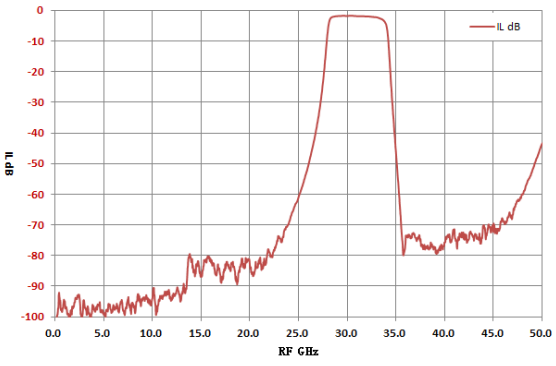
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



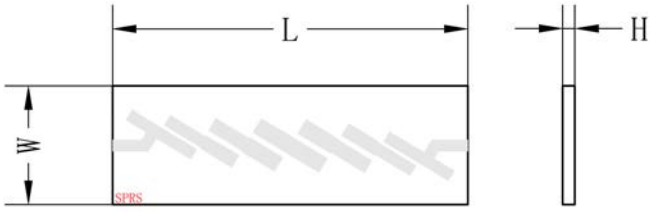
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	29.1	GHz
工作带宽	28.4-29.8	GHz
中心损耗	2.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-26.6GHz	dBc
带外抑制	25@31.2-40.0GHz	dBc

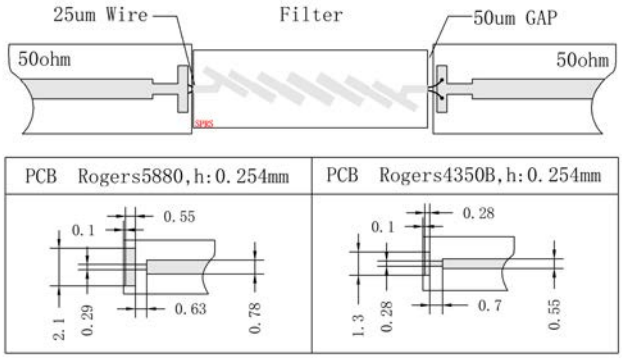
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



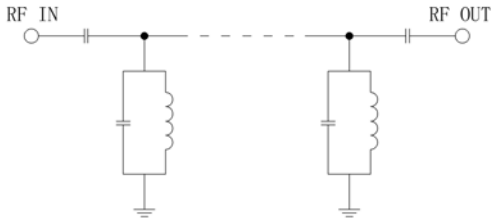
推荐装配图



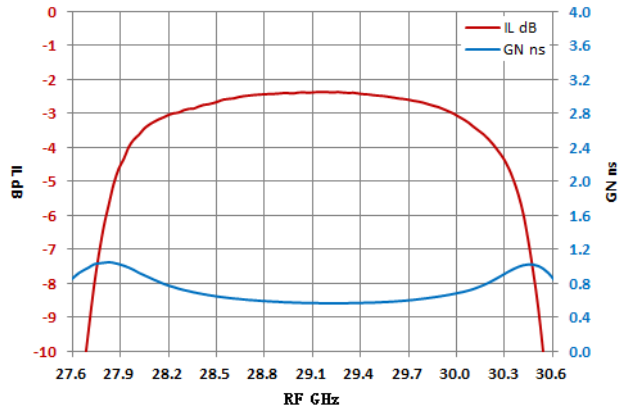
注意事项

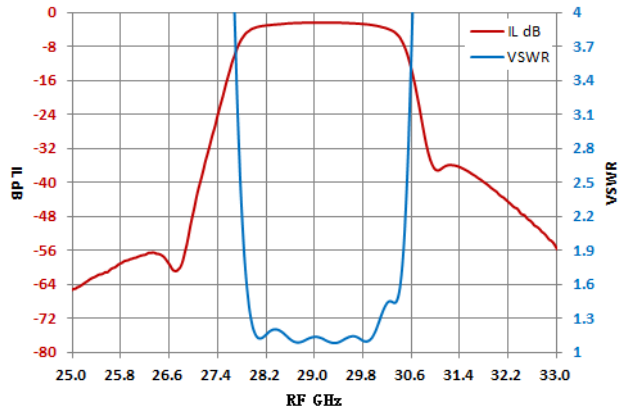
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

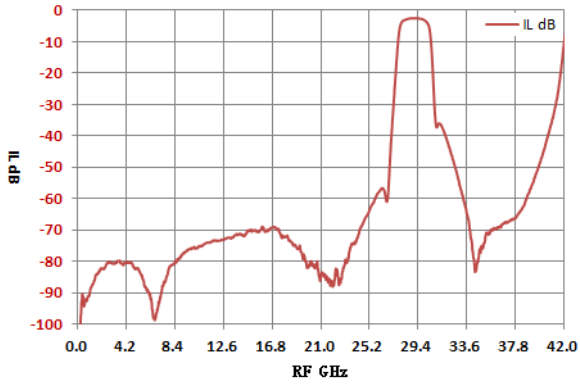
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

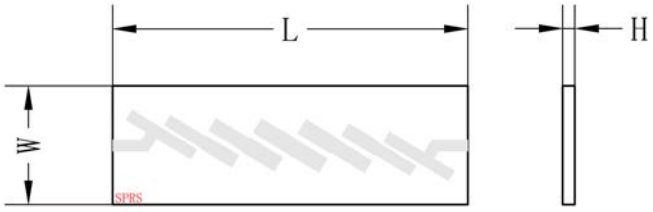
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	34.7	GHz
工作带宽	28.4-41.0	GHz
中心损耗	2.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-22.7GHz	dBc
带外抑制	40@46.5-53.0GHz	dBc

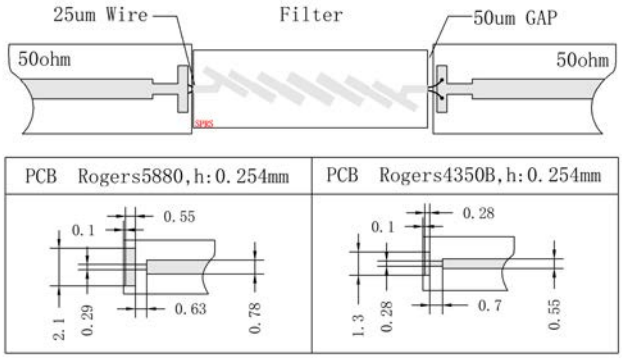
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：1.8，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



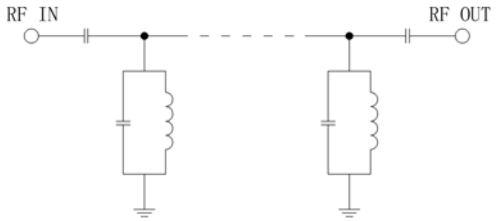
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖175mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

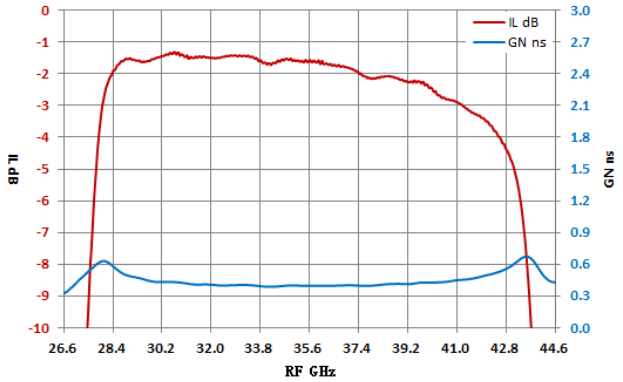
参考实物图

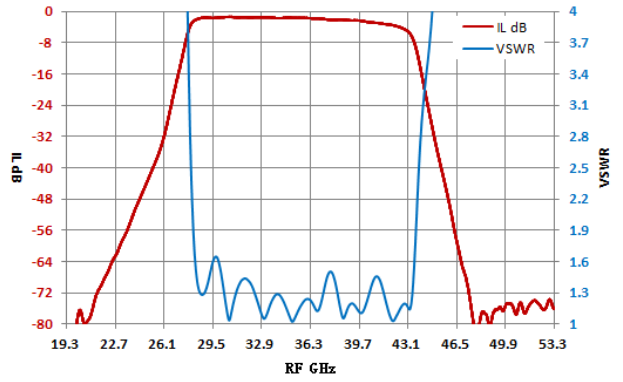


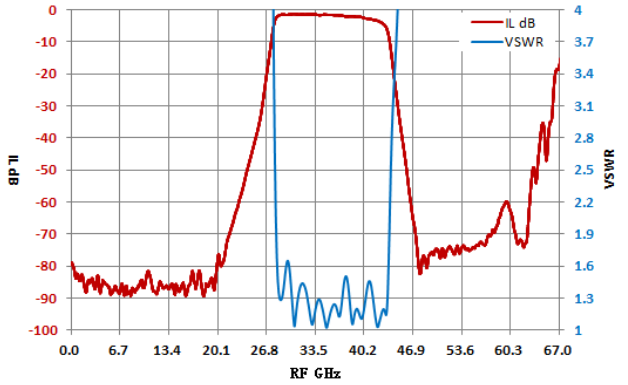
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



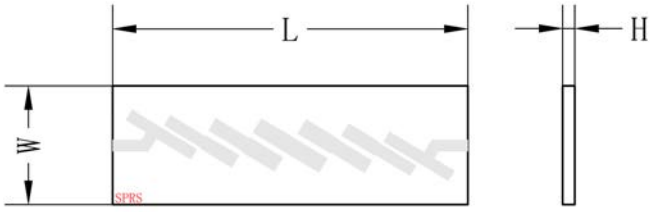
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	34.7	GHz
工作带宽	28.6-40.8	GHz
中心损耗	2.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-22.5GHz	dBc
带外抑制	40@49.5-62.0GHz	dBc

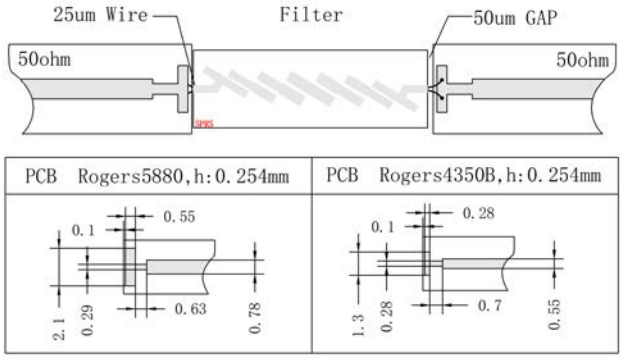
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：1.6，h：0.26

外形图：端口居中



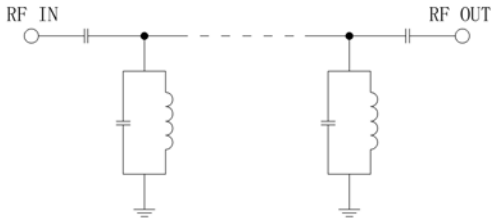
推荐装配图



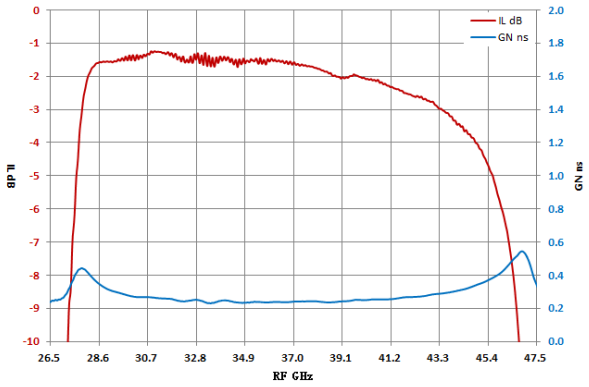
注意事项

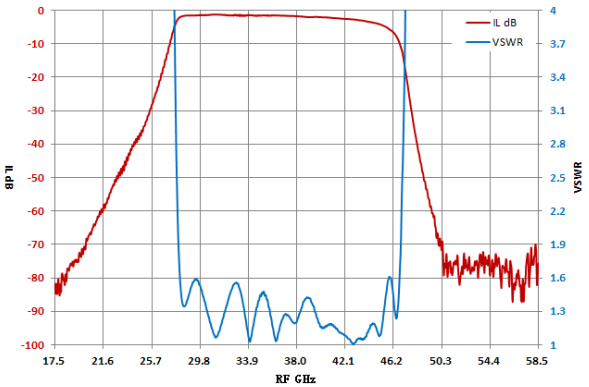
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

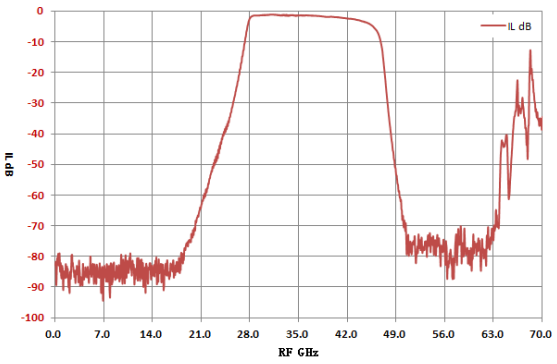
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

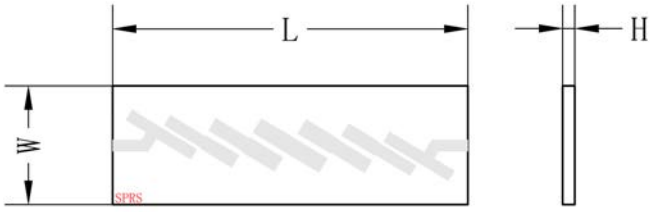
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	30.0	GHz
工作带宽	28.7-31.3	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-25.0GHz	dBc
带外抑制	40@34.0-45.0GHz	dBc

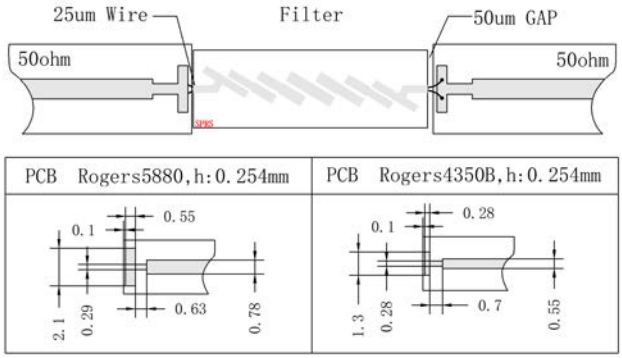
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



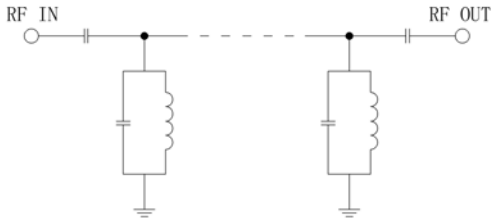
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

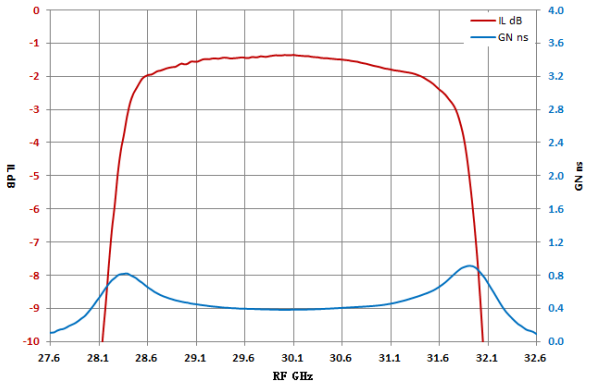
参考实物图

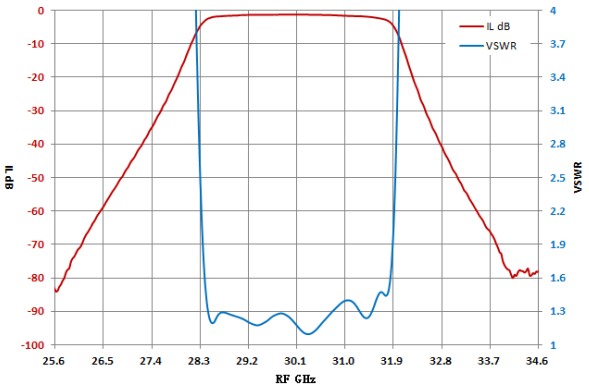


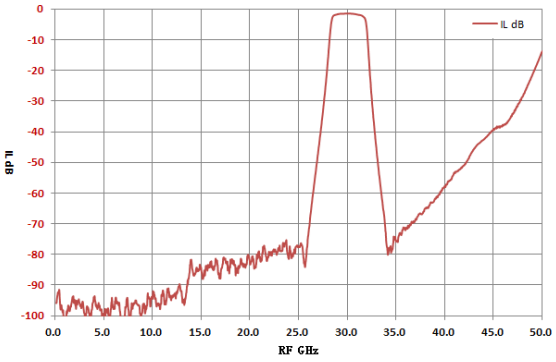
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



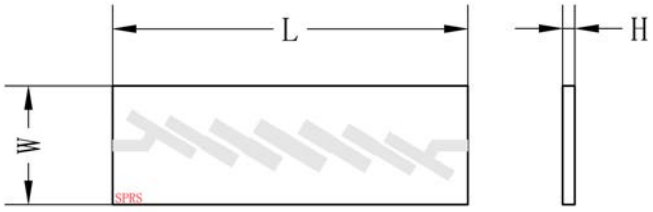
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	29.7	GHz
工作带宽	28.8-30.6	GHz
中心损耗	2.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-26.0GHz	dBc
带外抑制	40@33.0-50.0GHz	dBc

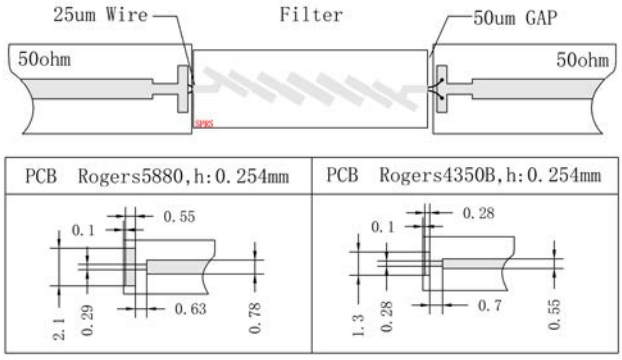
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



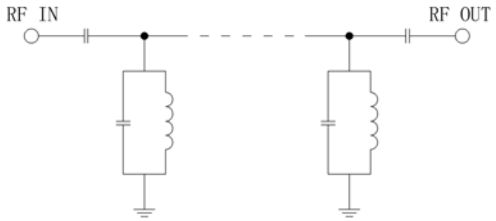
推荐装配图



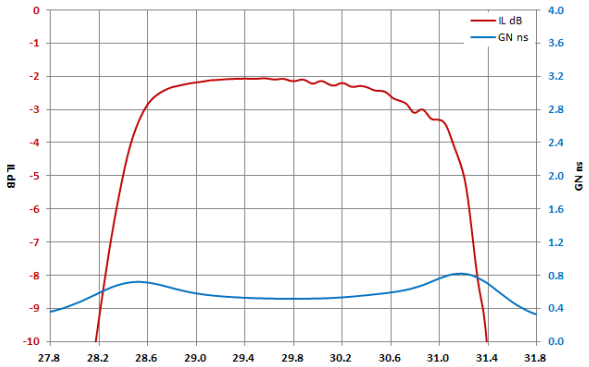
注意事项

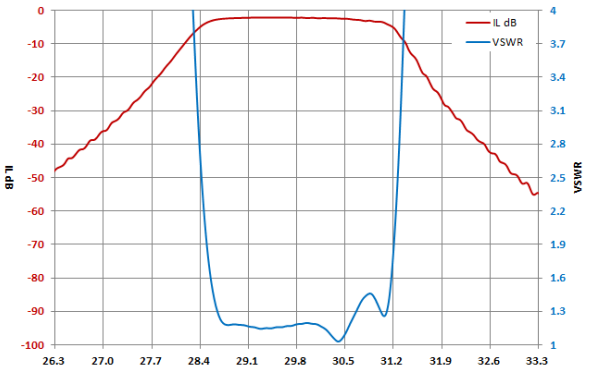
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

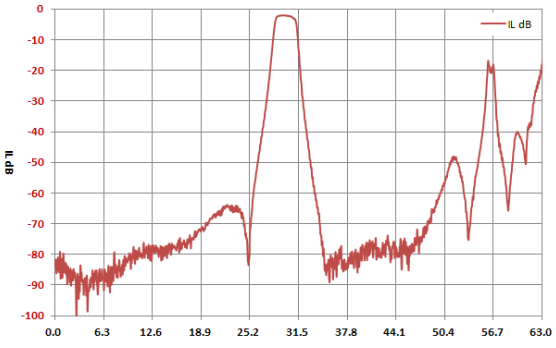
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



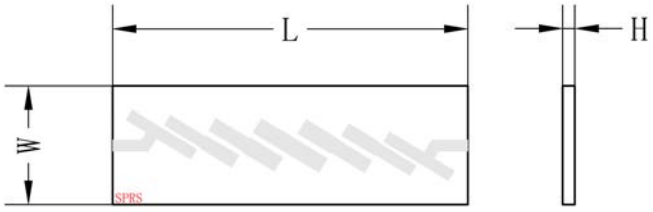
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	30.7	GHz
工作带宽	28.9-32.5	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-25.3GHz	dBc
带外抑制	40@35.2-48.0GHz	dBc

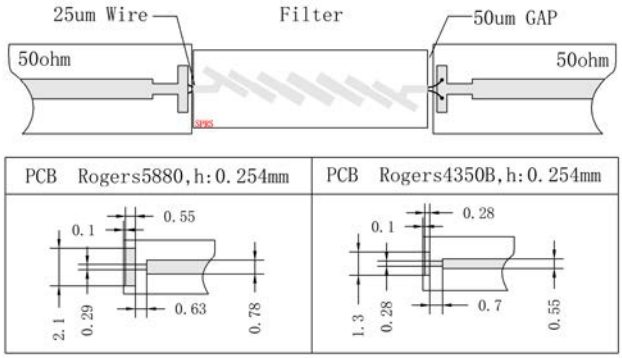
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



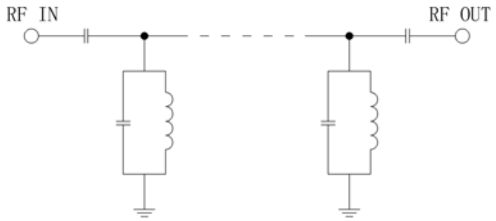
推荐装配图



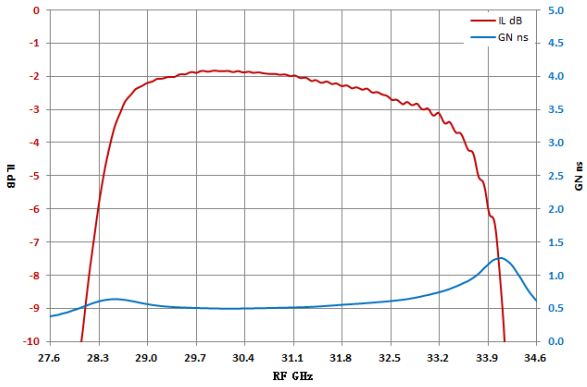
注意事项

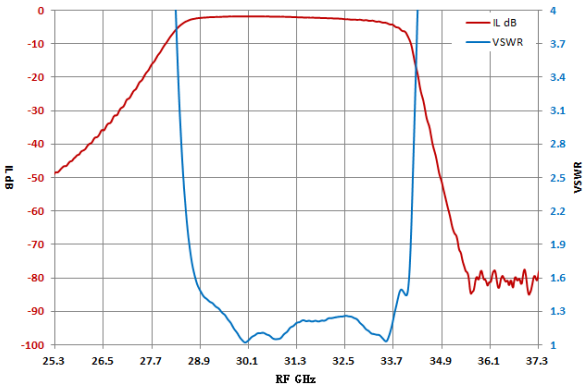
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

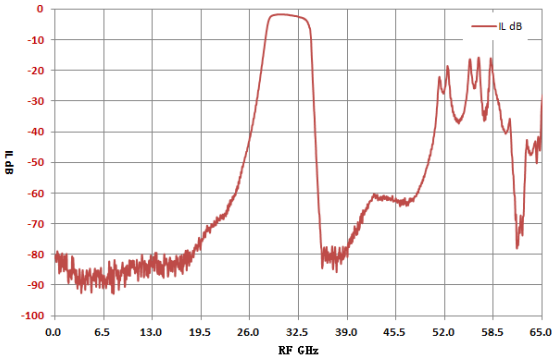
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



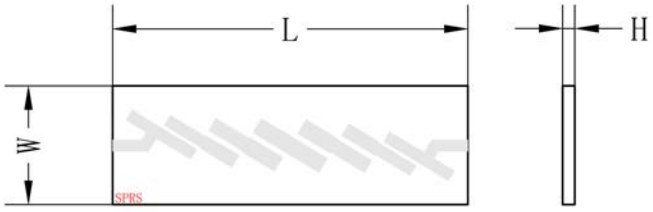
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	29.5	GHz
工作带宽	29.0-30.0	GHz
中心损耗	4.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-27.8GHz	dBc
带外抑制	40@31.5-40.0GHz	dBc

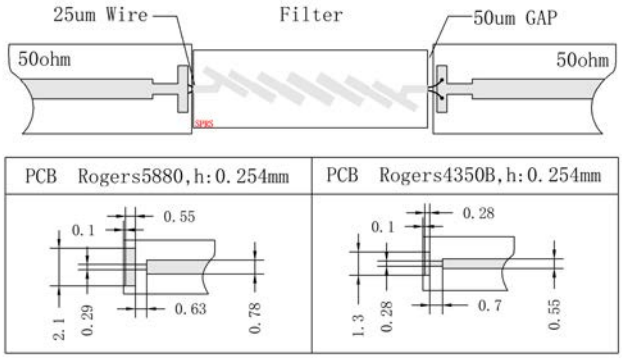
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：10.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



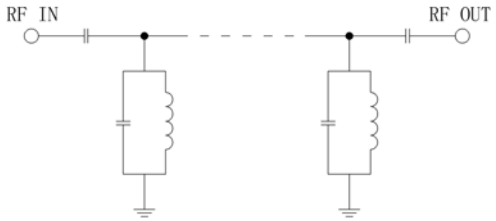
推荐装配图



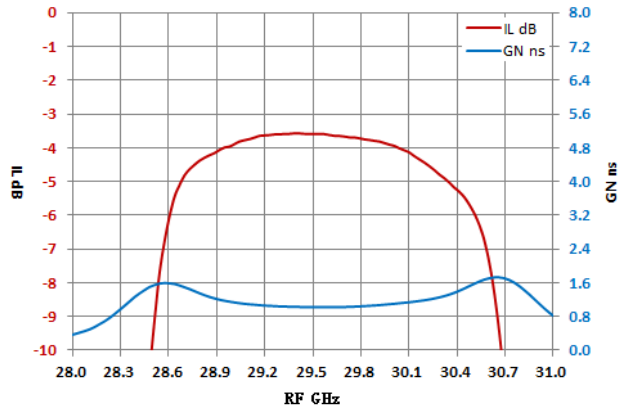
注意事项

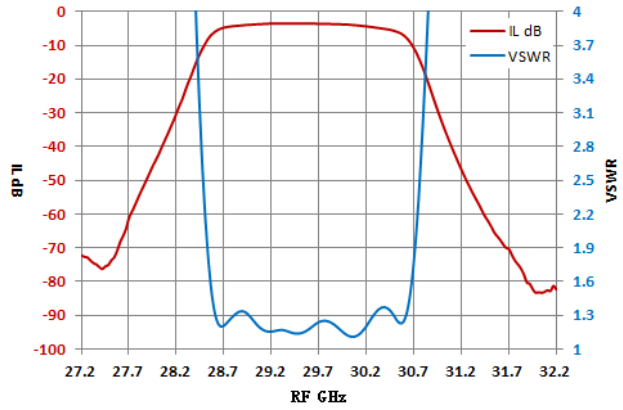
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

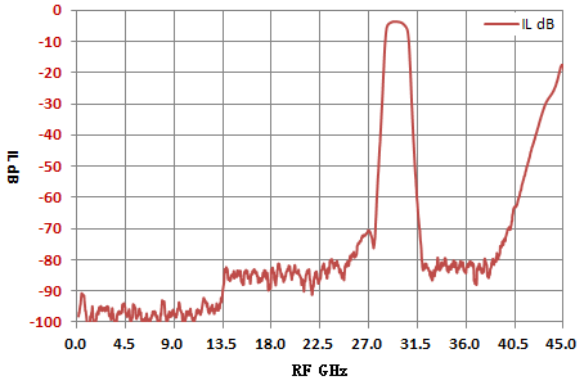
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

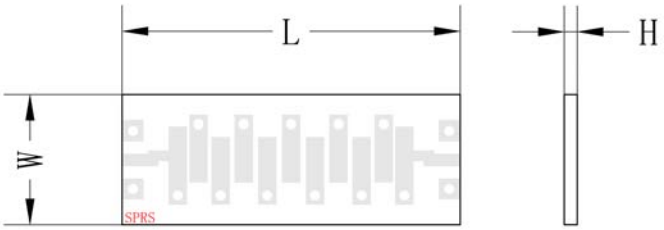
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	29.9	GHz
工作带宽	29.0-30.8	GHz
中心损耗	2.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-27.3GHz	dBc
带外抑制	40@32.6-45.0GHz	dBc

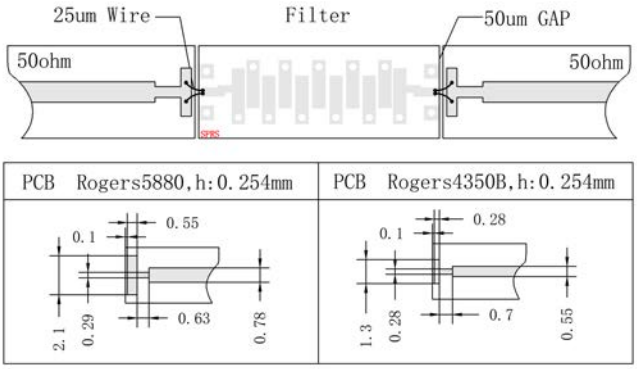
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：6.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

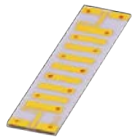
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

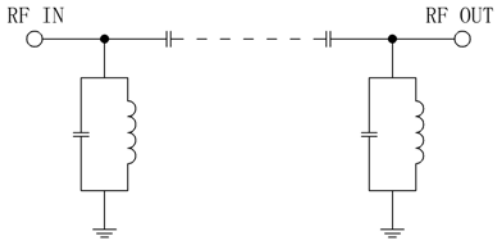
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

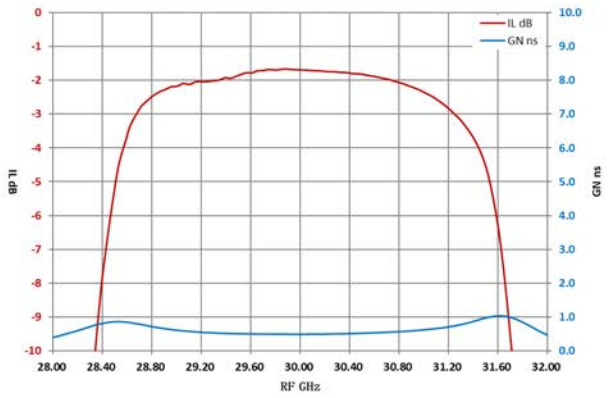
参考图

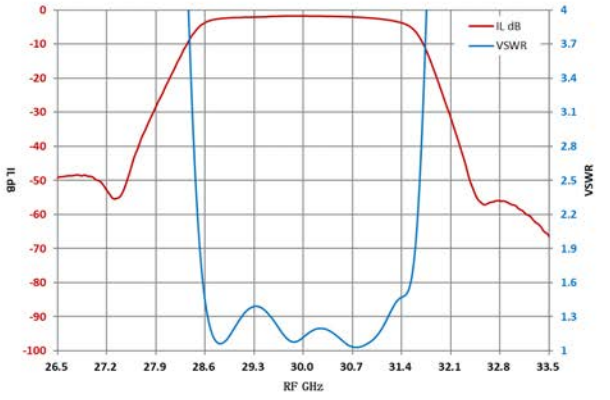


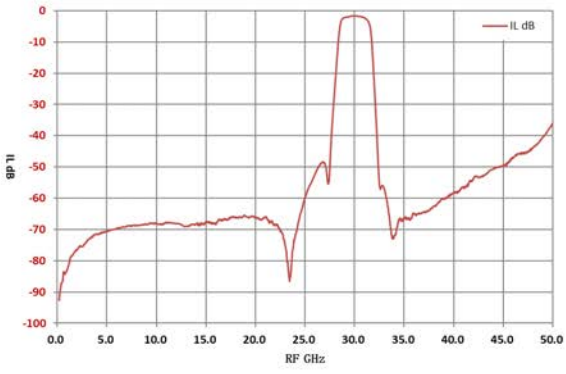
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



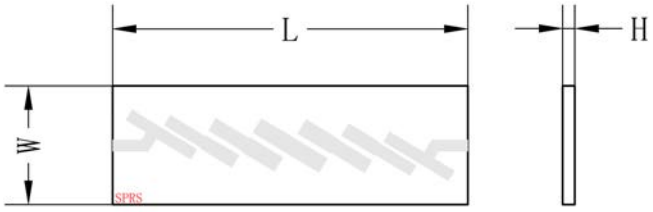
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	30.0	GHz
工作带宽	29.0-31.0	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-27.0GHz	dBc
带外抑制	40@33.0-39.0GHz	dBc

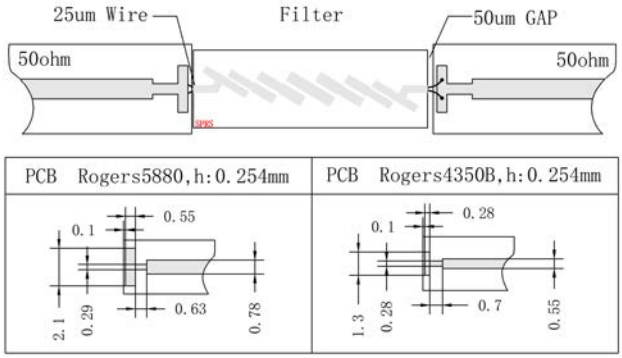
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



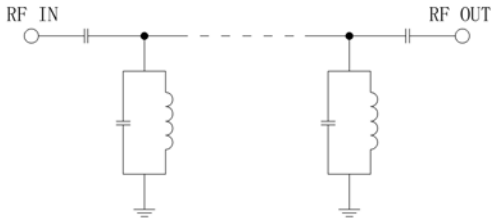
推荐装配图



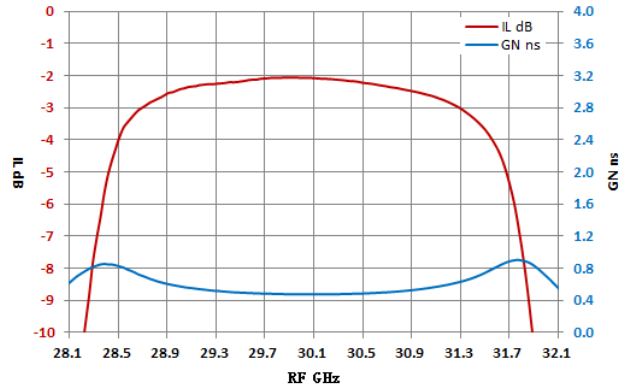
注意事项

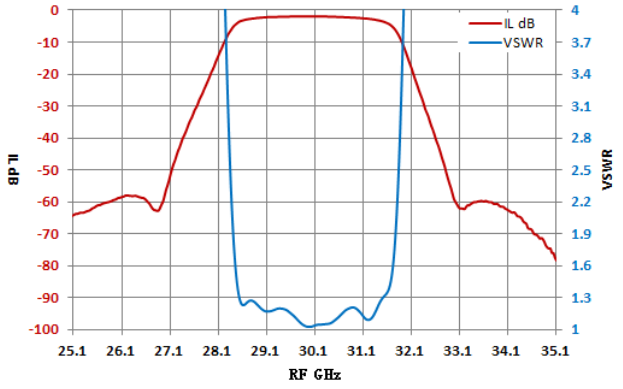
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

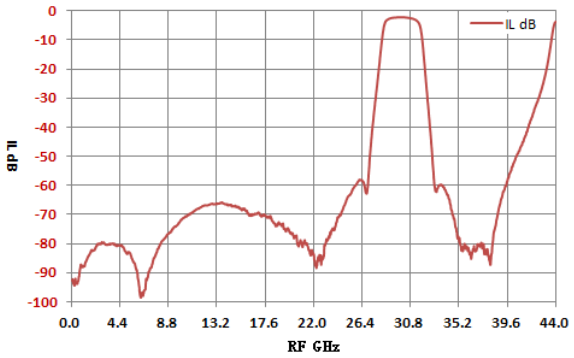
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



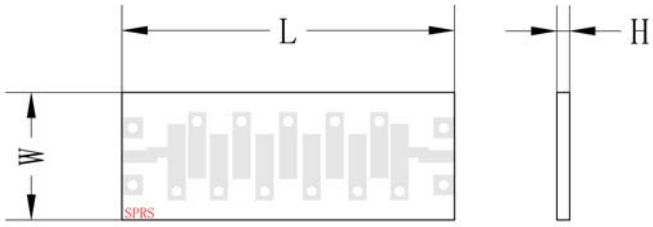
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	31.6	GHz
工作带宽	29.0-34.2	GHz
中心损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-26.8GHz	dBc
带外抑制	40@36.7-47.0GHz	dBc

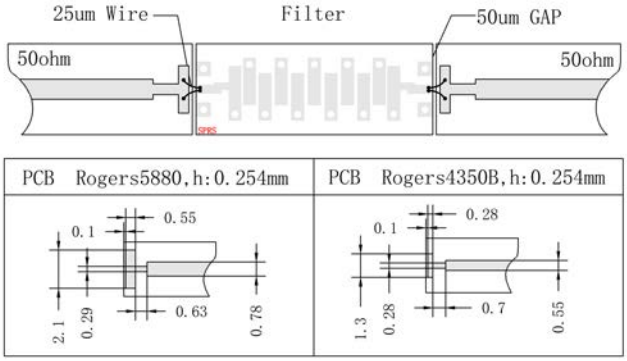
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



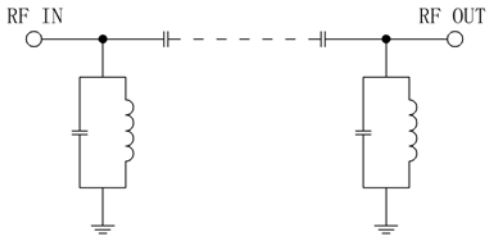
推荐装配图



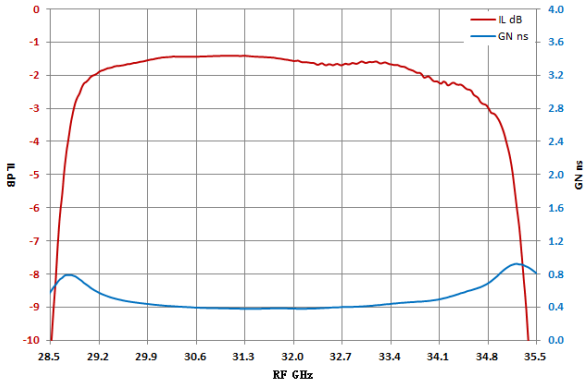
注意事项

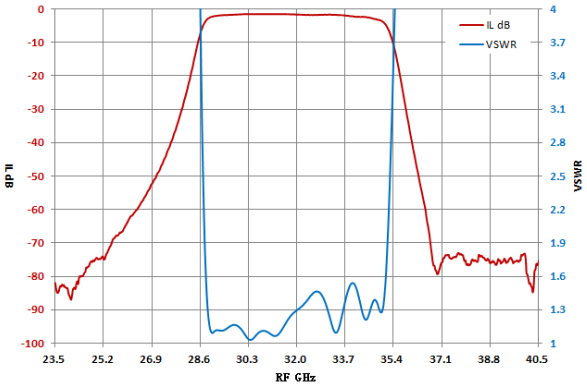
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

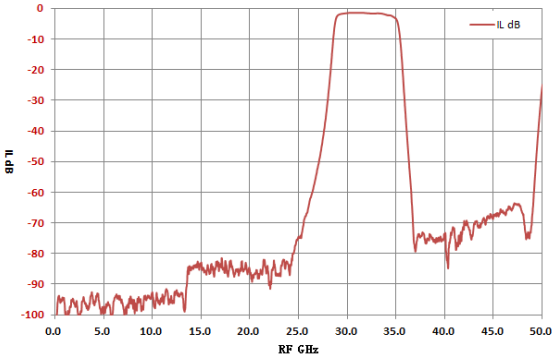
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

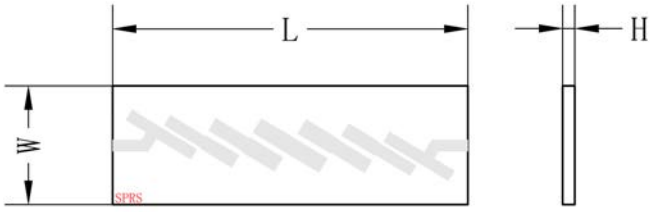
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	31.7	GHz
工作带宽	29.0-34.4	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-26.1GHz	dBc
带外抑制	40@38.1-46.0GHz	dBc

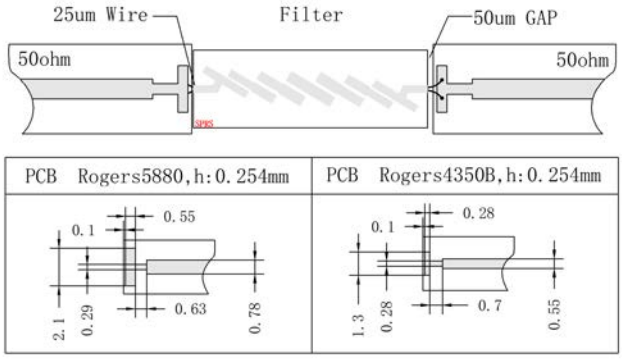
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



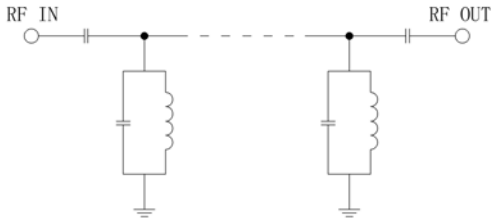
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

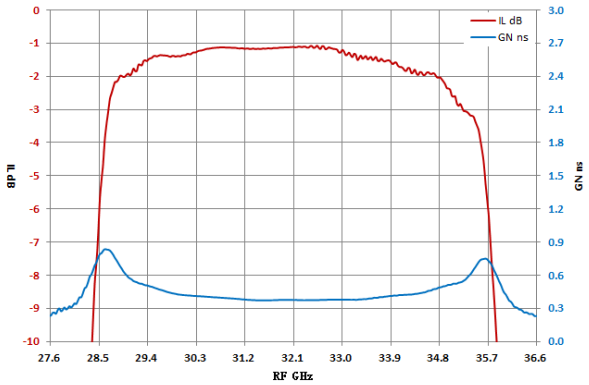
参考实物图

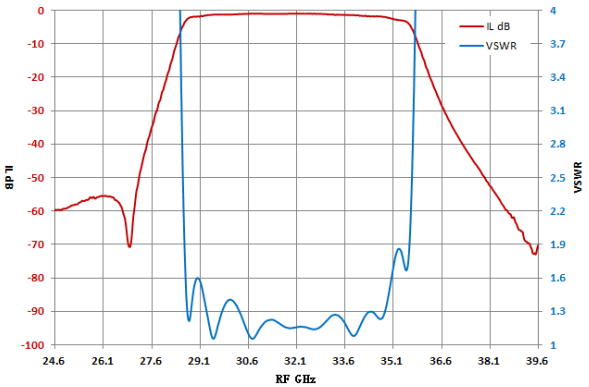


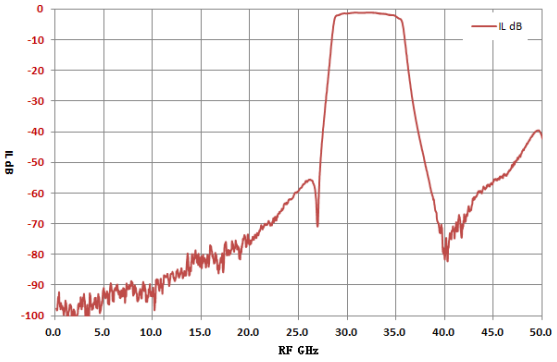
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

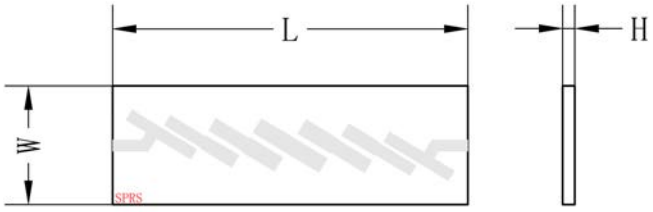
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	31.9	GHz
工作带宽	29.0-34.8	GHz
中心损耗	1.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-26.1GHz	dBc
带外抑制	40@38.3-45.0GHz	dBc

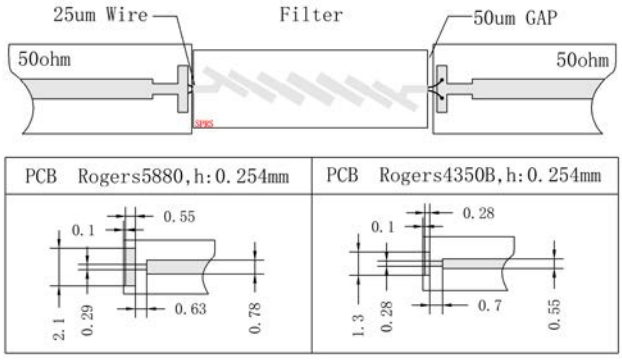
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



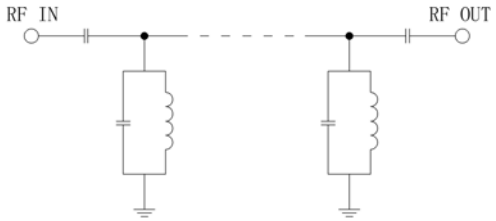
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

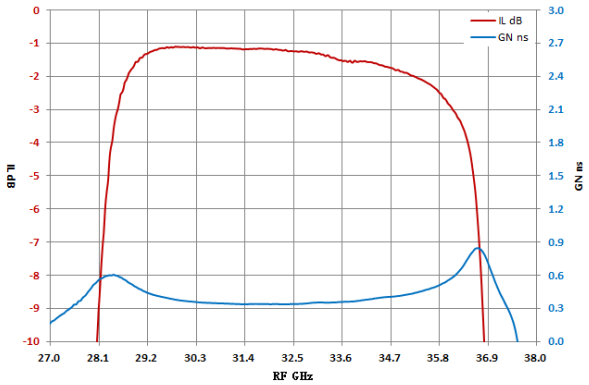
参考实物图

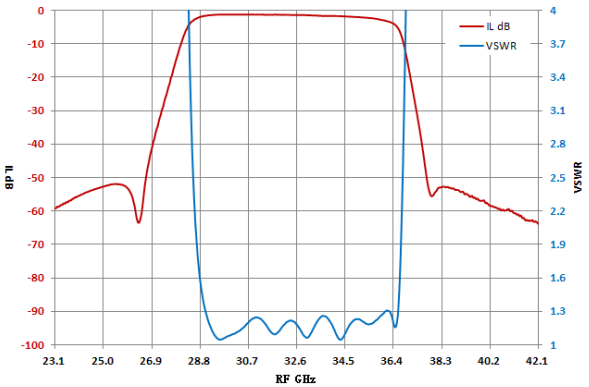


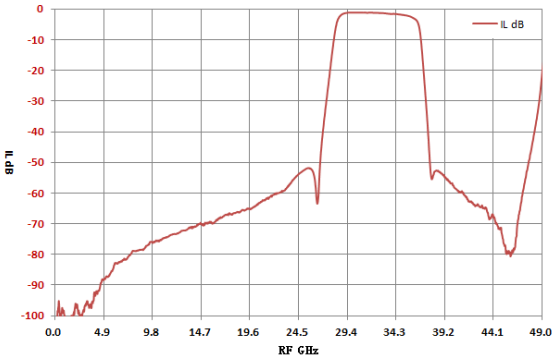
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



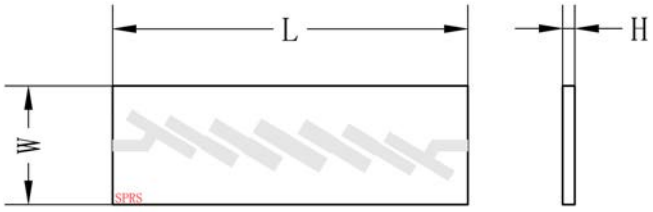
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	32.2	GHz
工作带宽	29.0-35.4	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-26.7GHz	dBc
带外抑制	40@38.5-44.0GHz	dBc

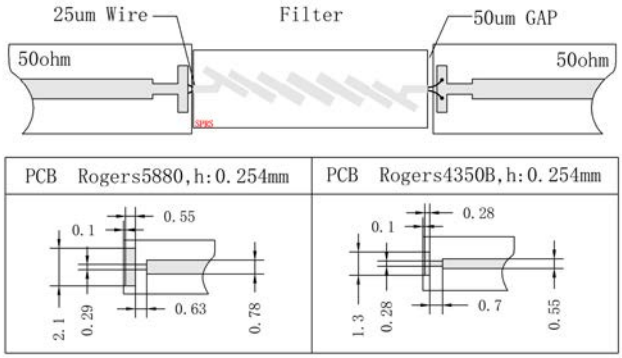
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



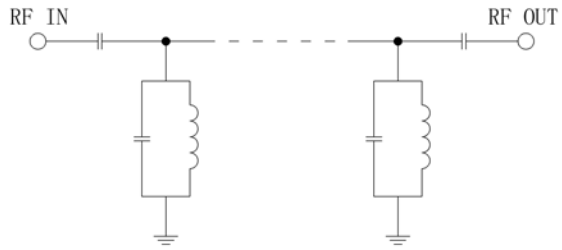
推荐装配图



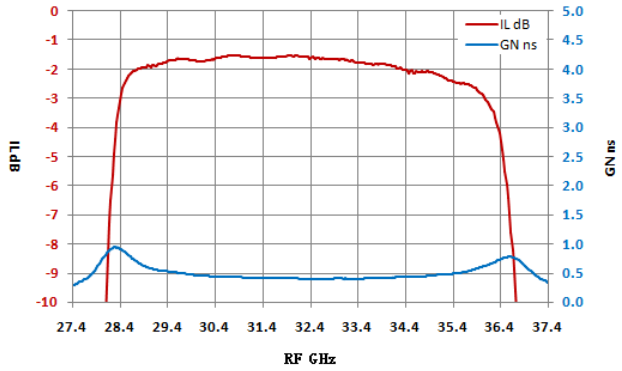
注意事项

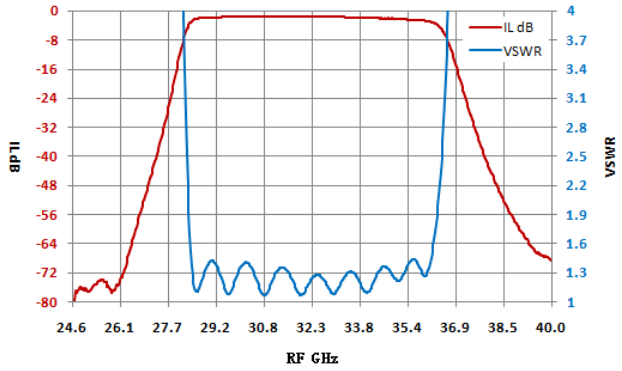
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

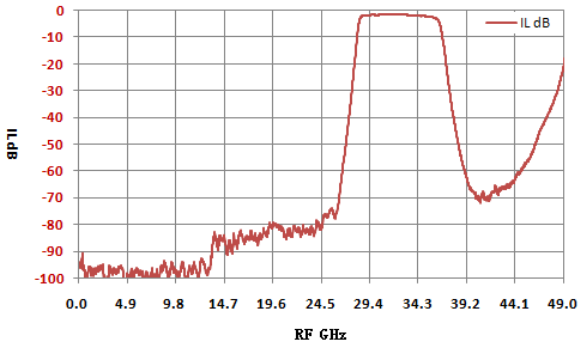
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



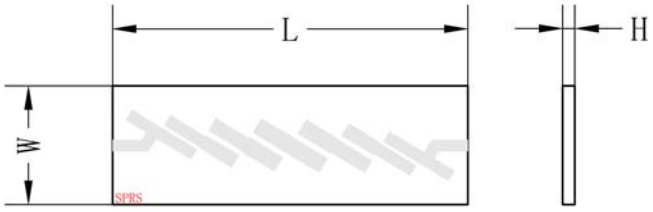
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	33.0	GHz
工作带宽	29.2-36.8	GHz
中心损耗	1.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-26.0GHz	dBc
带外抑制	40@41.2-51.0GHz	dBc

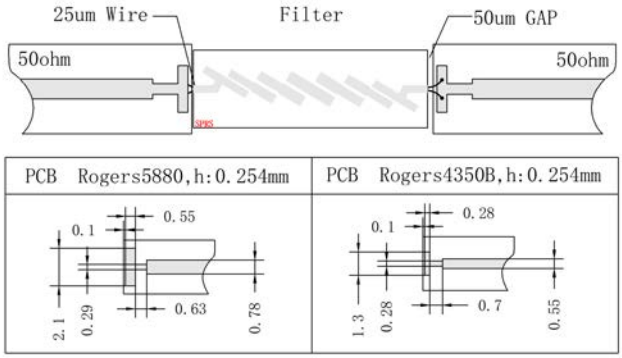
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



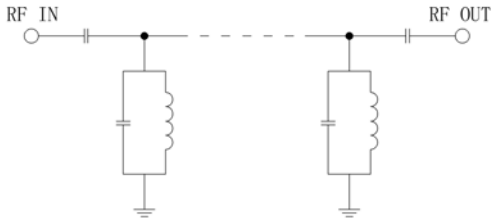
推荐装配图



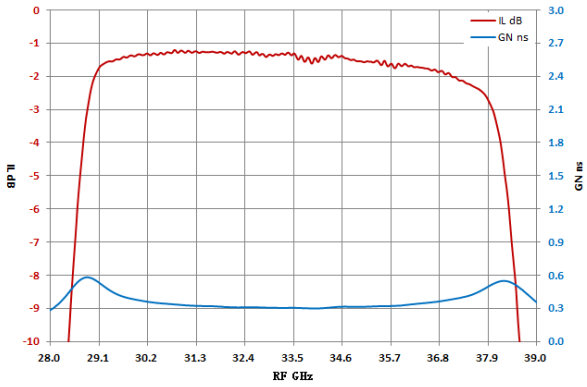
注意事项

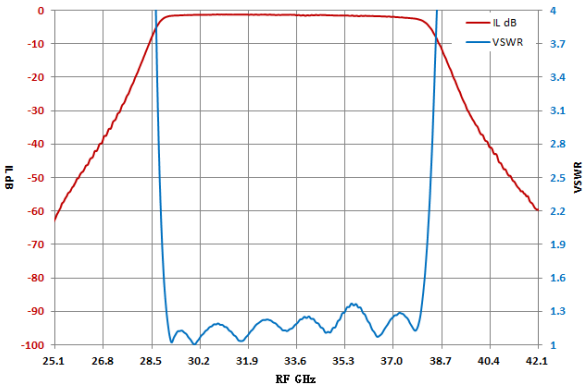
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

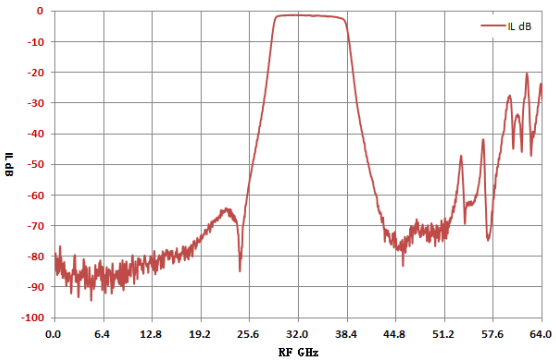
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



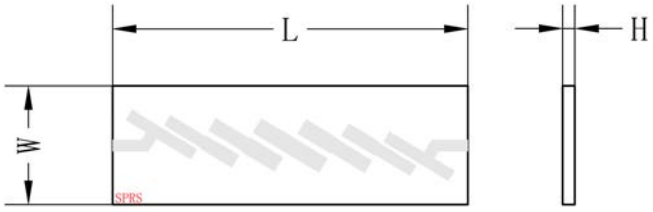
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	30.0	GHz
工作带宽	29.3-30.7	GHz
中心损耗	3.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	37@DC-28.0GHz	dBc
带外抑制	25@32.2-39.0GHz	dBc

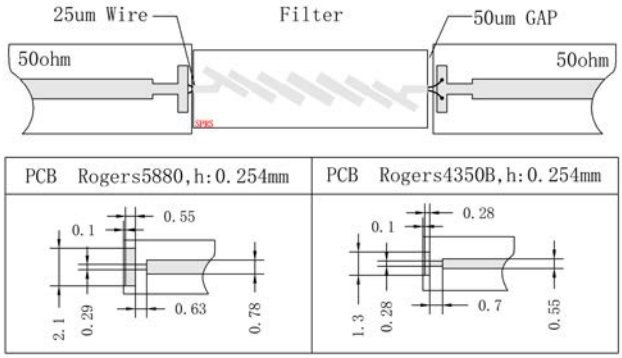
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



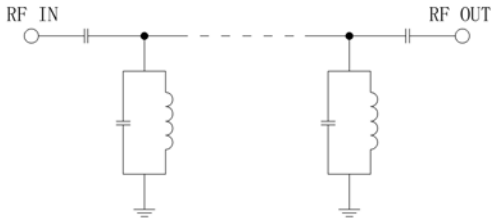
推荐装配图



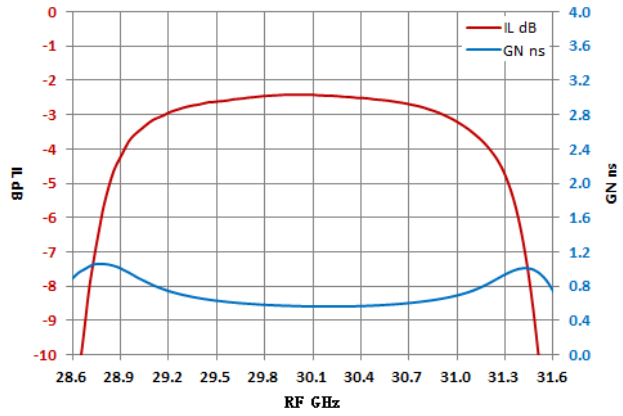
注意事项

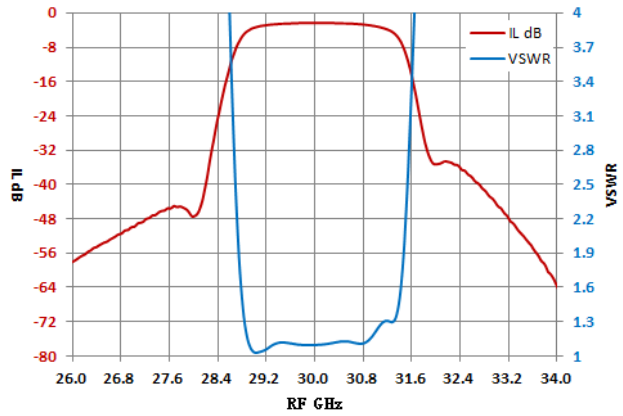
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

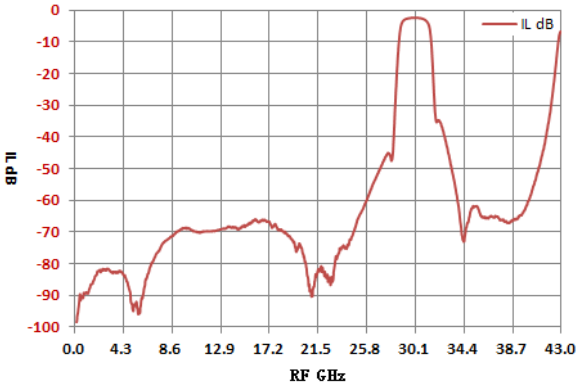
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

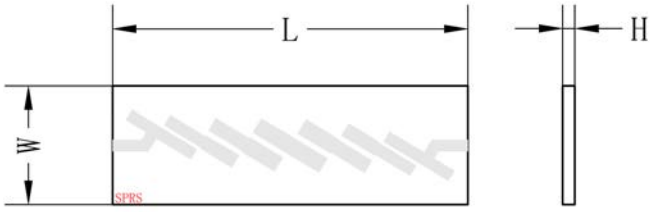
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	31.7	GHz
工作带宽	29.4-34.0	GHz
中心损耗	1.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-27.6GHz	dBc
带外抑制	40@38.0-45.0GHz	dBc

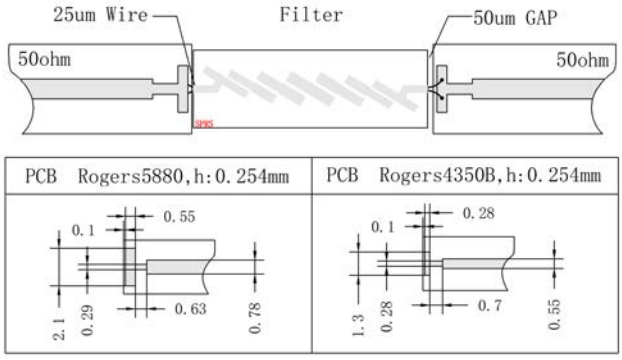
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



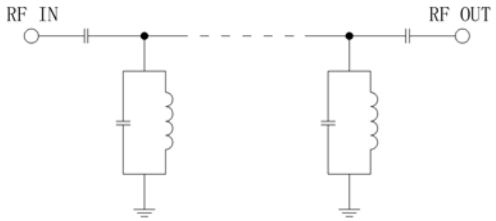
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

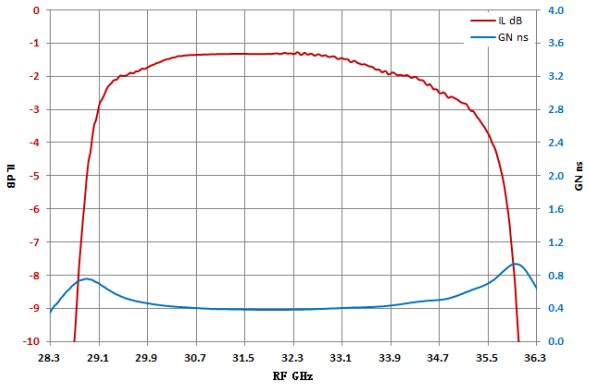
参考实物图

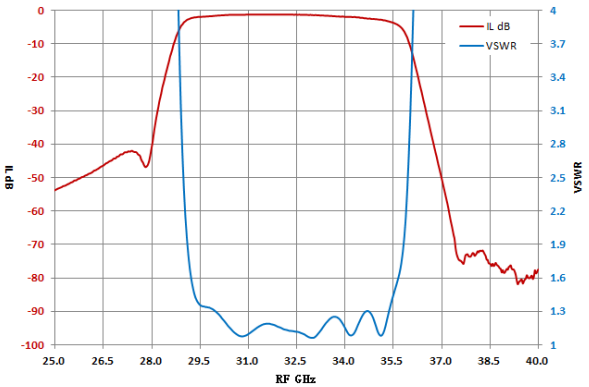


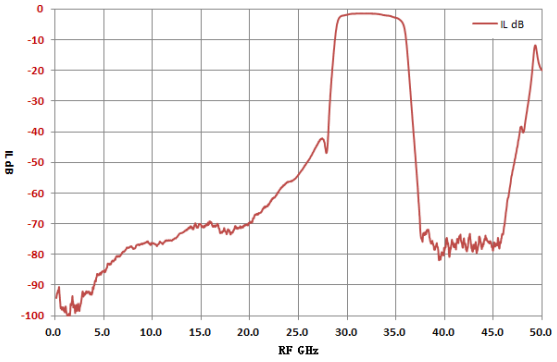
原理图



典型曲线







陶瓷滤波器 STBP340-9R2-K334

工作带宽 29.4-38.6GHz,带外抑制 40@DC-25.0GHz,40@44.2-55.0GHz

产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



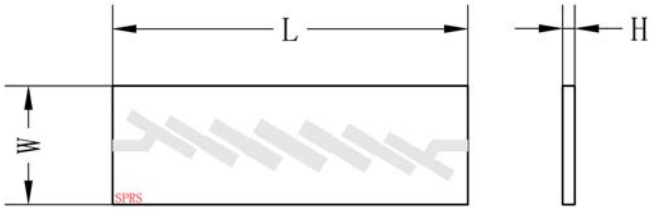
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	34.0	GHz
工作带宽	29.4-38.6	GHz
中心损耗	1.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-25.0GHz	dBc
带外抑制	40@44.2-55.0GHz	dBc

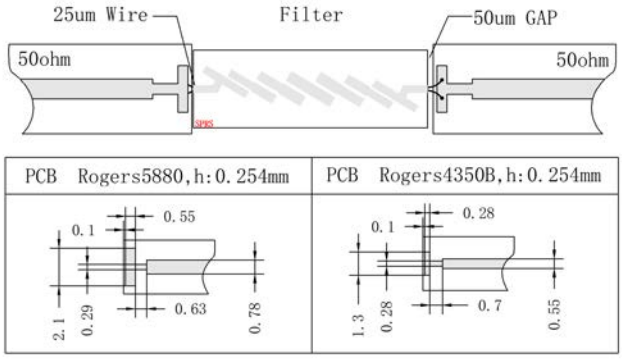
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



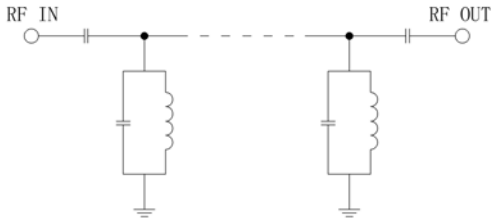
推荐装配图



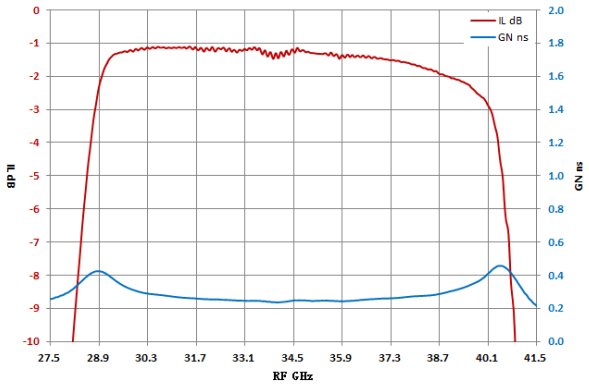
注意事项

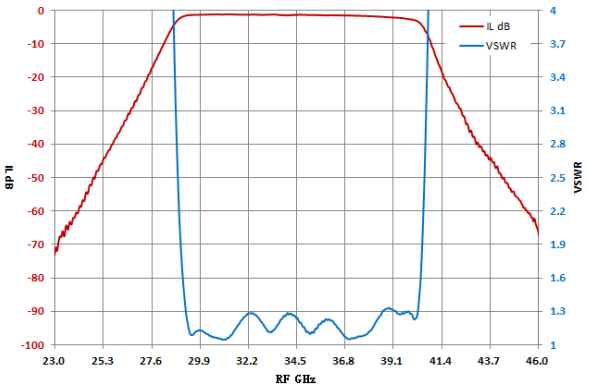
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

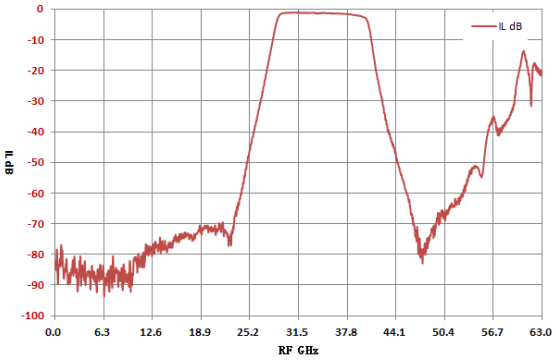
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



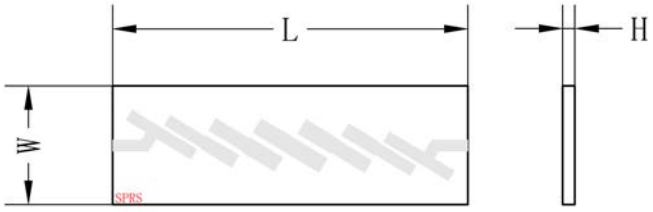
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	29.9	GHz
工作带宽	29.6-30.2	GHz
中心损耗	4.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-28.1GHz	dBc
带外抑制	40@31.6-38.0GHz	dBc

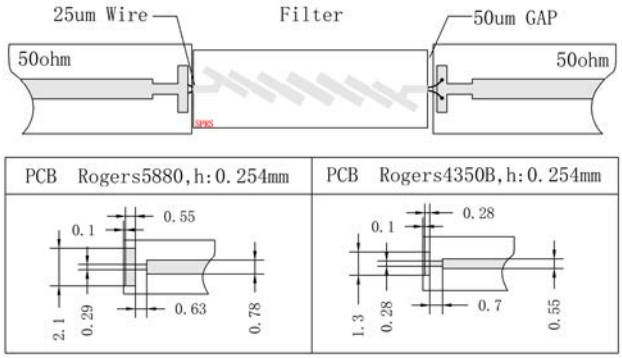
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



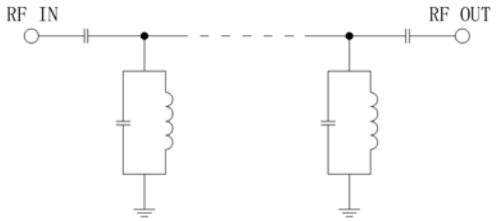
推荐装配图



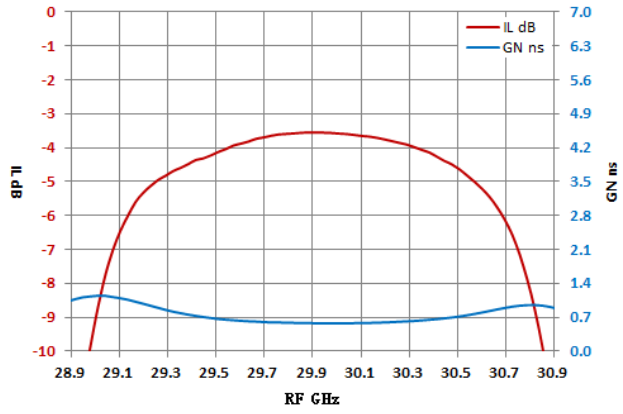
注意事项

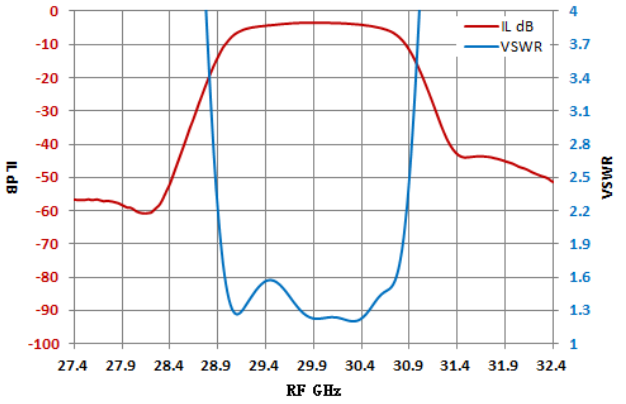
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

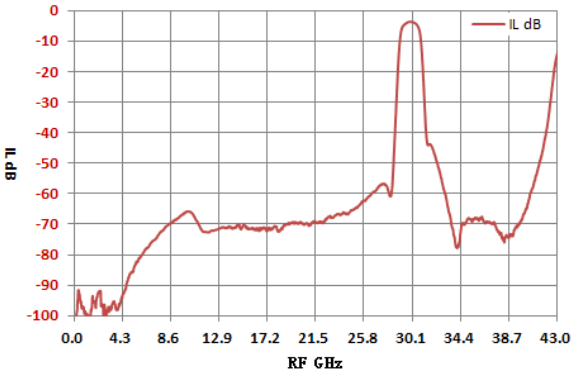
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



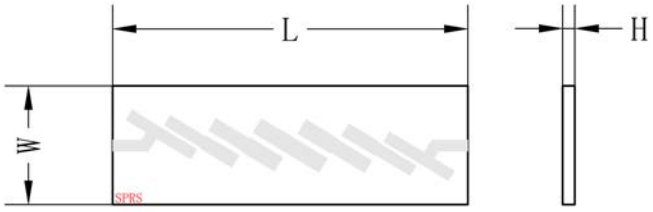
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	30.6	GHz
工作带宽	29.6-31.6	GHz
中心损耗	2.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-27.2GHz	dBc
带外抑制	40@33.8-44.0GHz	dBc

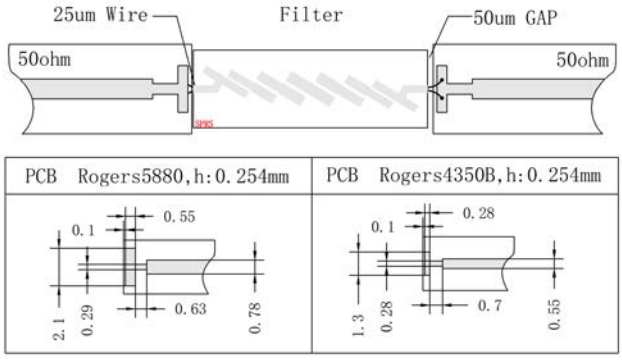
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



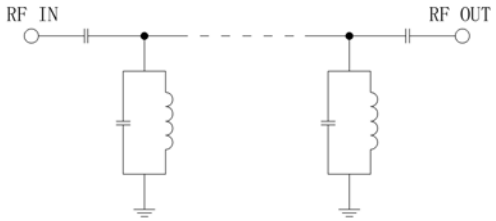
推荐装配图



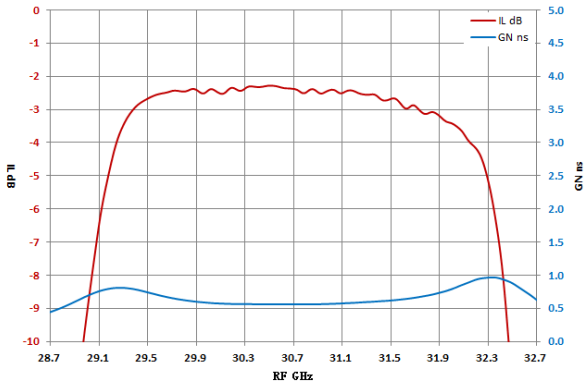
注意事项

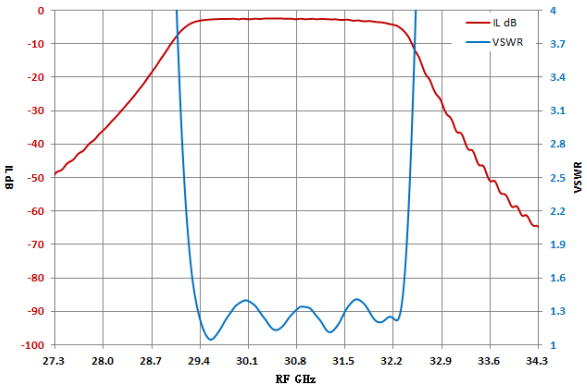
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

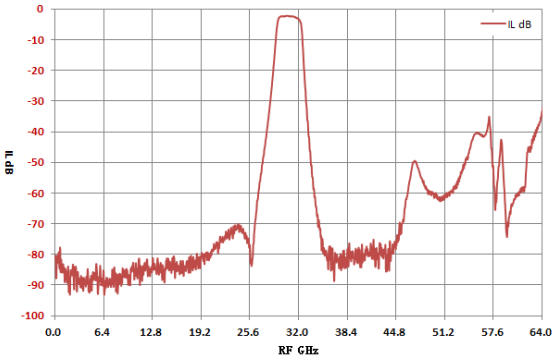
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

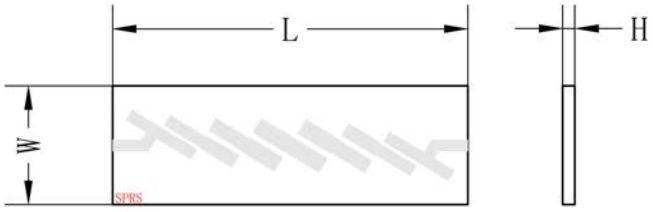
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	33.1	GHz
工作带宽	29.6-36.6	GHz
中心损耗	2.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-24.7GHz	dBc
带外抑制	40@42.7-44.0GHz	dBc

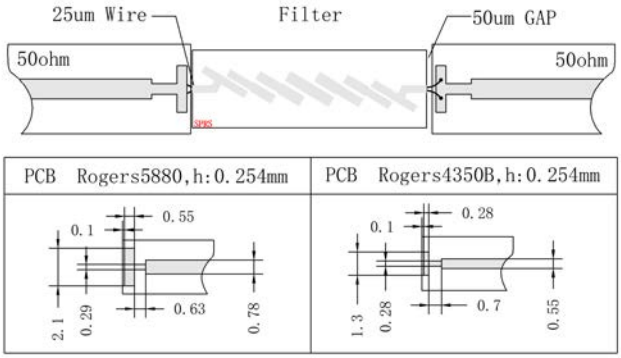
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



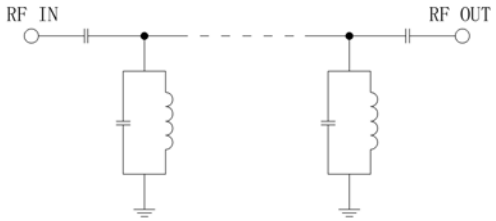
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

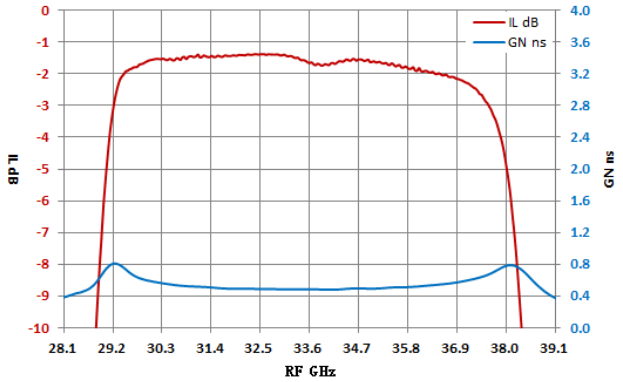
参考实物图

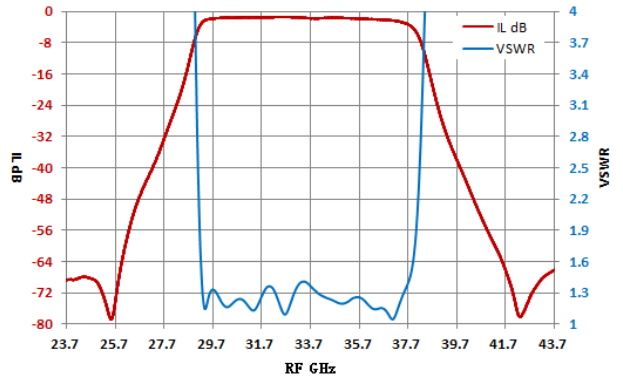


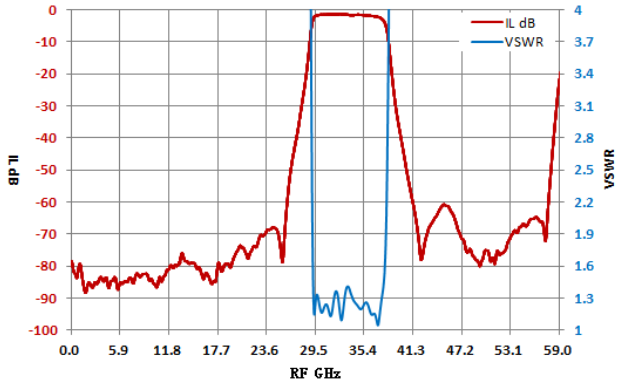
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

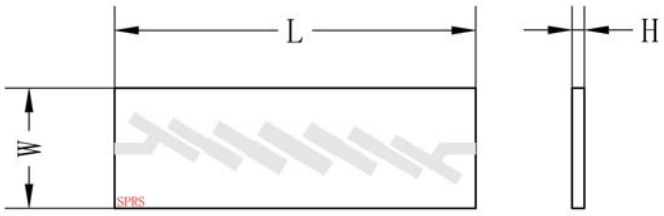
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	35.2	GHz
工作带宽	29.6-40.8	GHz
中心损耗	2.0	dB
带内波动	2.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-26.6GHz	dBc
带外抑制	40@45.0-54.0GHz	dBc

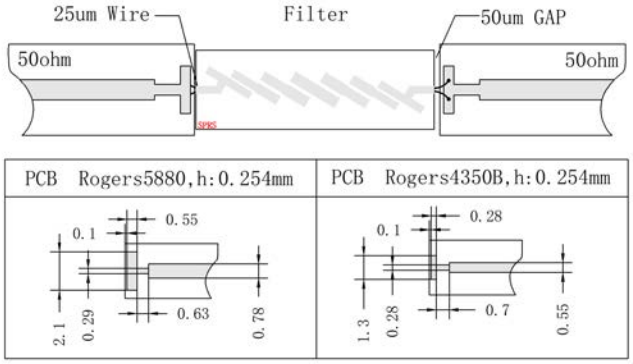
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：7.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

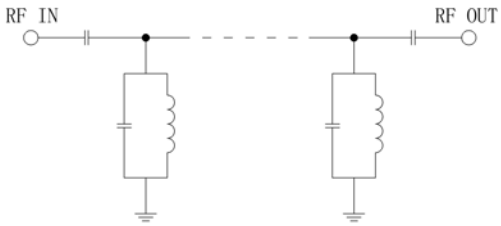
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

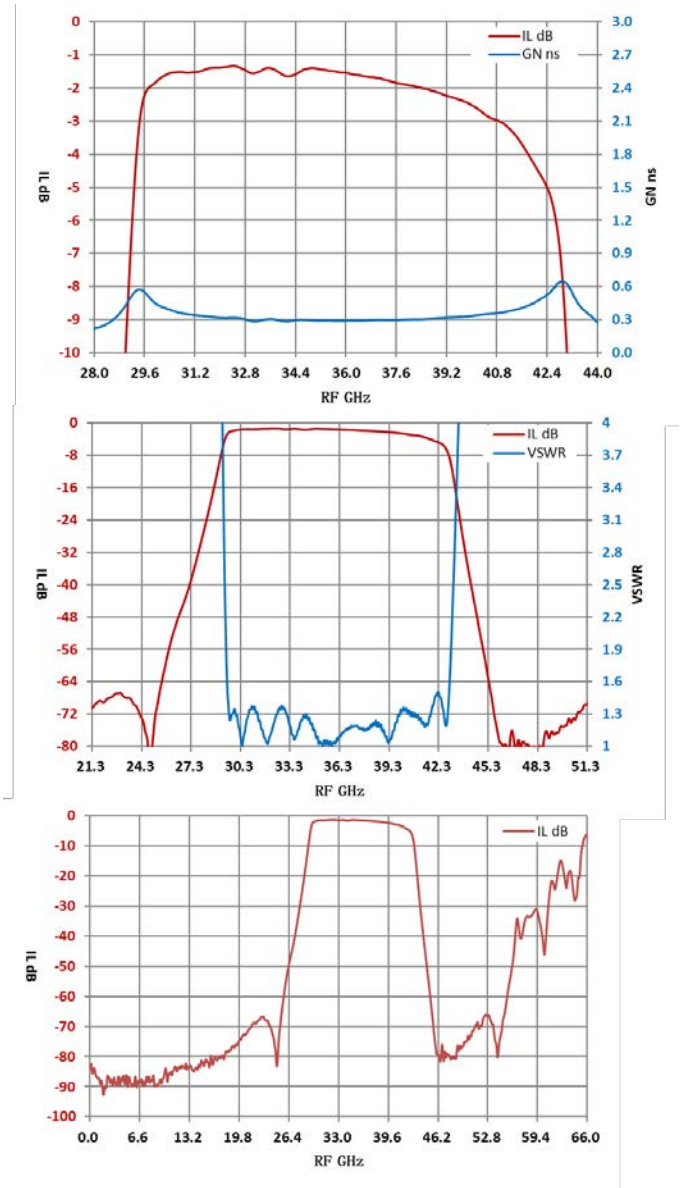
参考图



原理图



典型曲线



产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

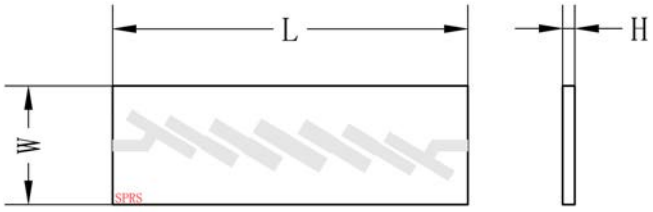
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	31.7	GHz
工作带宽	29.8-33.6	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-28.1GHz	dBc
带外抑制	40@35.9-45.0GHz	dBc

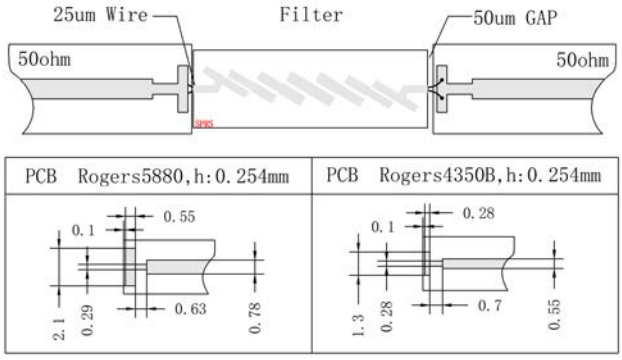
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



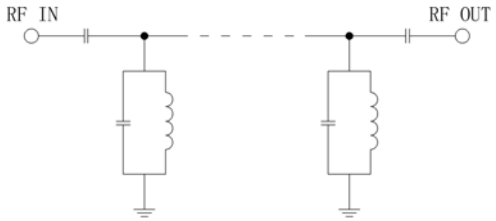
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

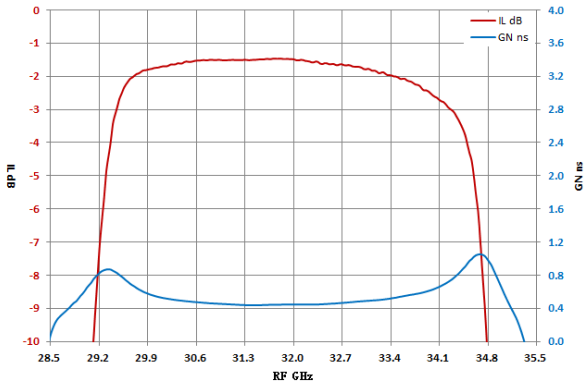
参考实物图

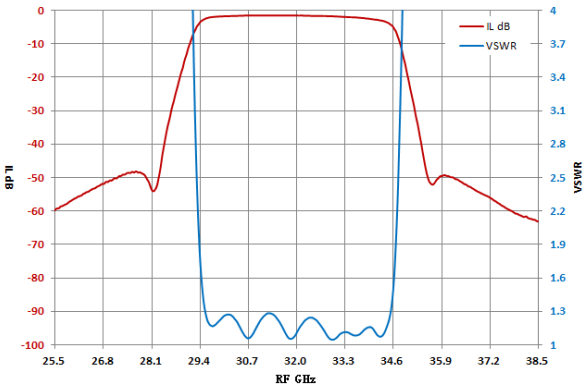


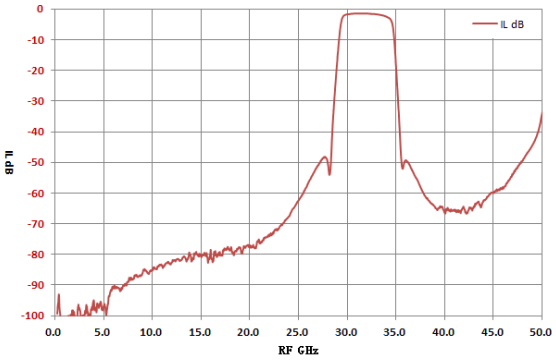
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

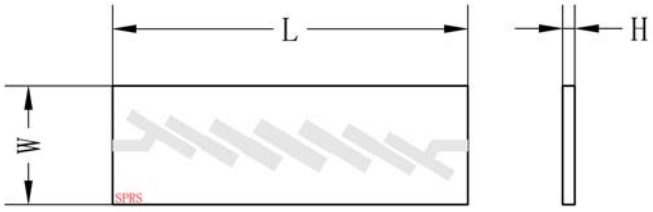
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	32.3	GHz
工作带宽	29.8-34.8	GHz
中心损耗	1.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-27.5GHz	dBc
带外抑制	40@38.7-45.0GHz	dBc

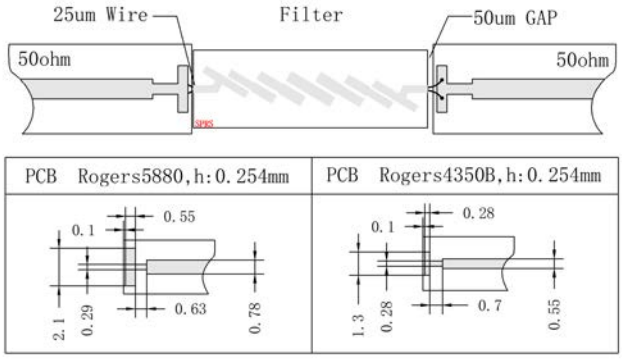
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：11.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



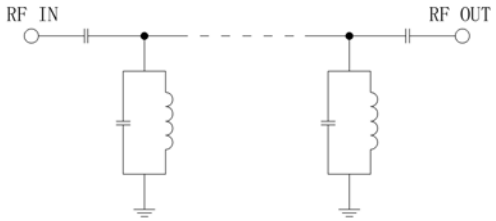
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

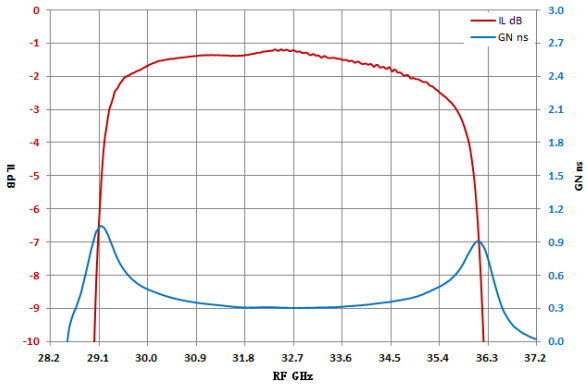
参考实物图

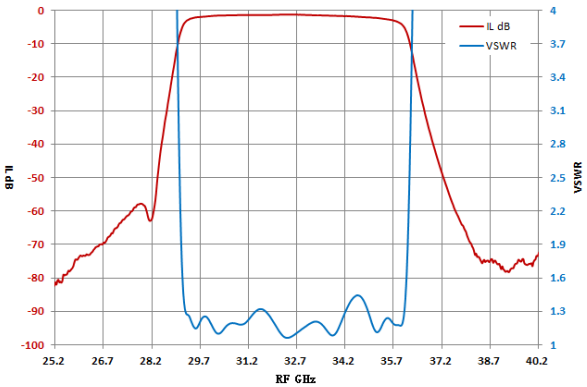


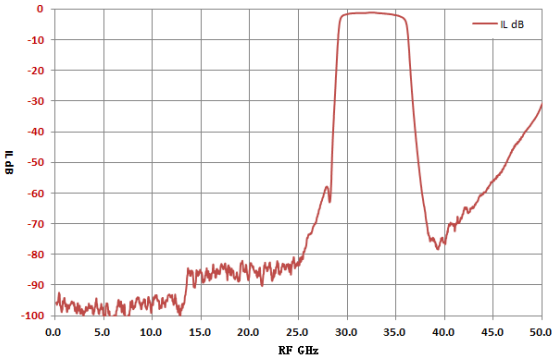
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

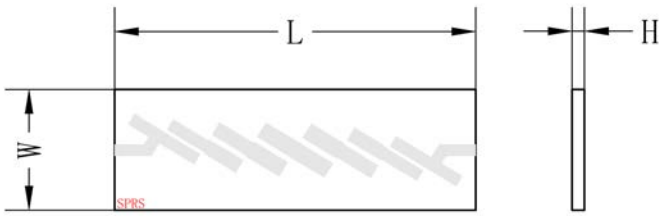
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	33.0	GHz
工作带宽	29.8-36.2	GHz
中心损耗	1.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-26.6GHz	dBc
带外抑制	40@41.0-45.0GHz	dBc

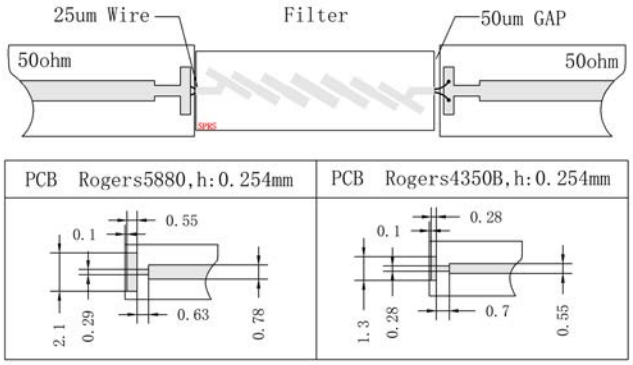
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：7.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

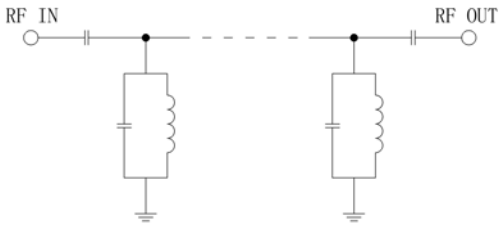
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

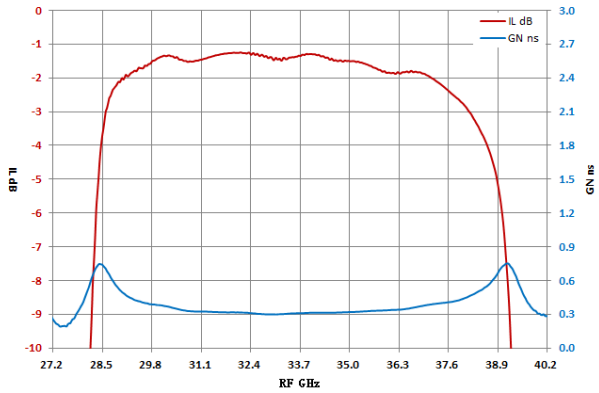
参考图

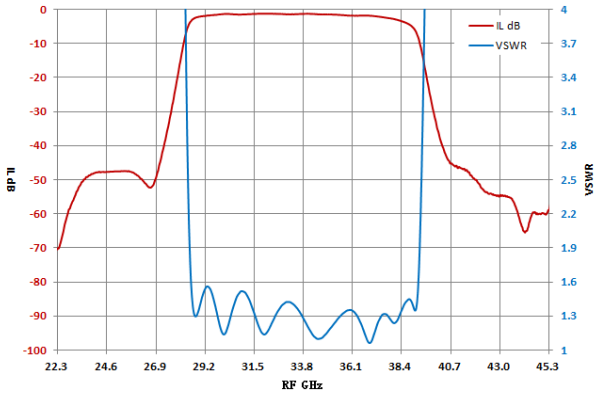


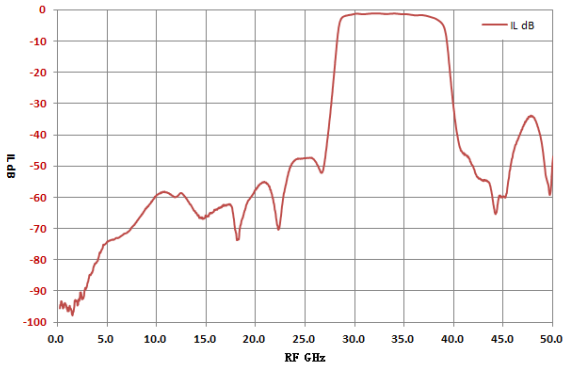
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



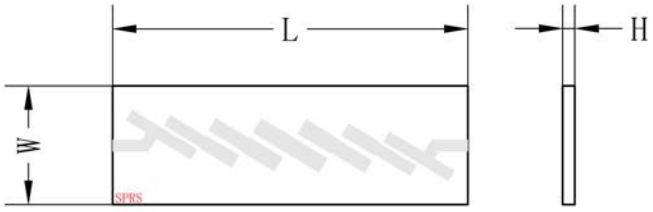
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	30.4	GHz
工作带宽	30.0-30.8	GHz
中心损耗	4.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-28.0GHz	dBc
带外抑制	40@32.2-52.0GHz	dBc

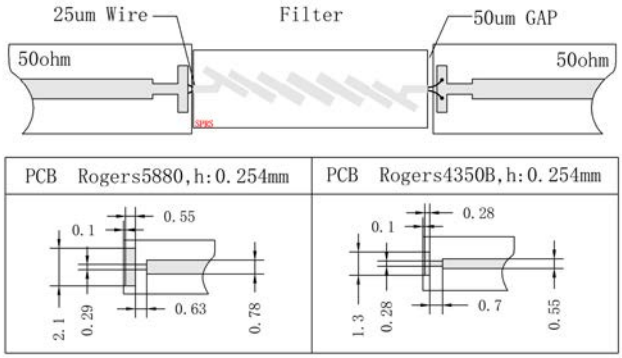
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



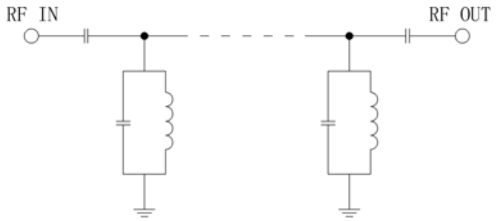
推荐装配图



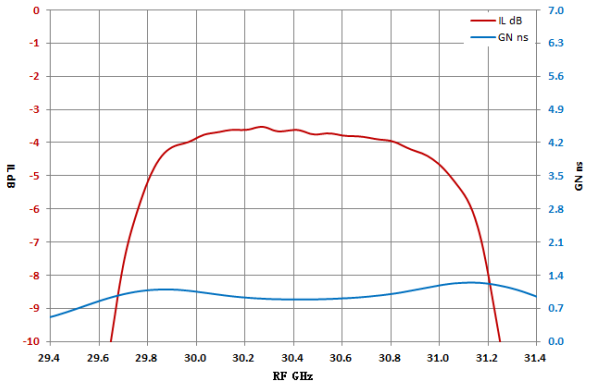
注意事项

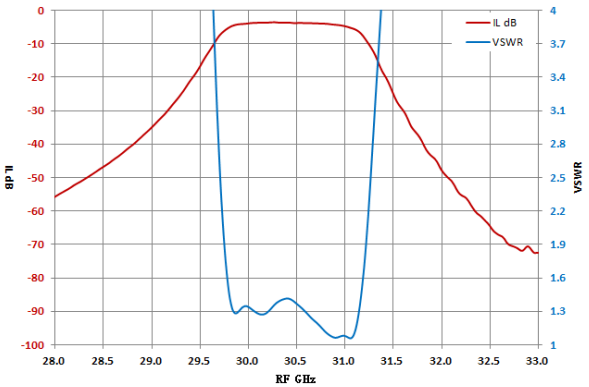
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

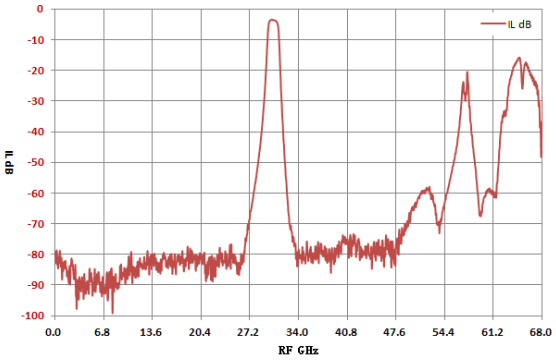
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



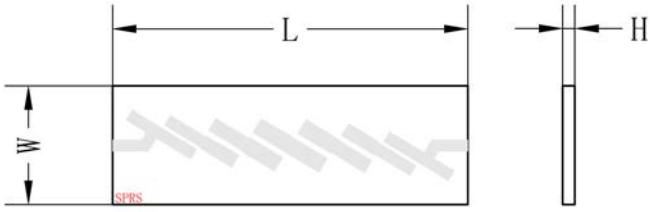
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	30.7	GHz
工作带宽	30.0-31.3	GHz
中心损耗	3.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-28.9GHz	dBc
带外抑制	40@32.5-44.0GHz	dBc

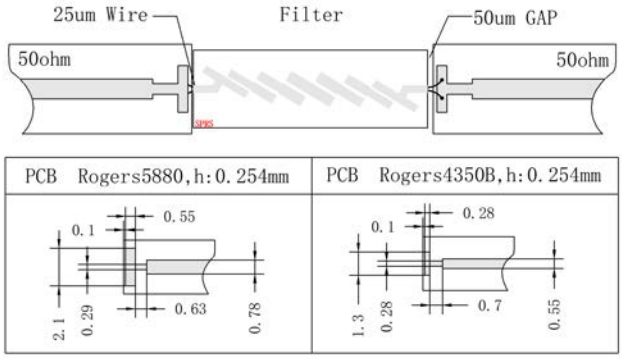
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：10.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



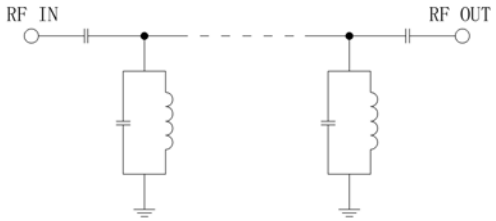
推荐装配图



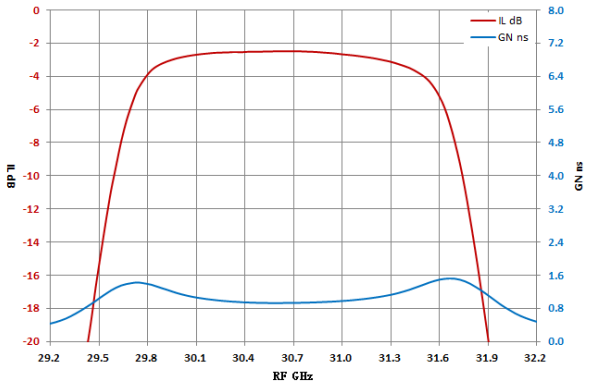
注意事项

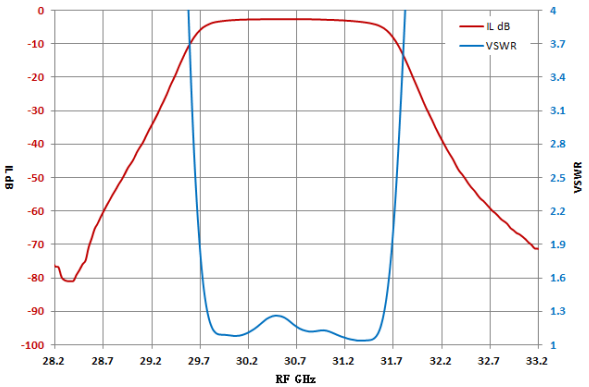
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

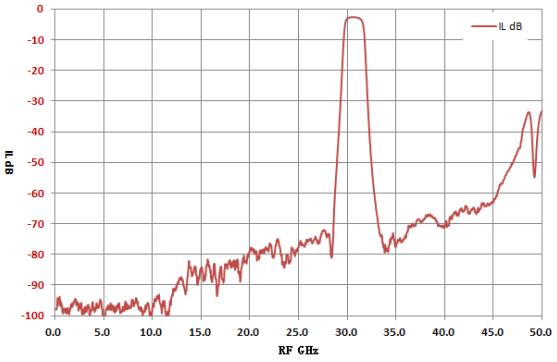
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

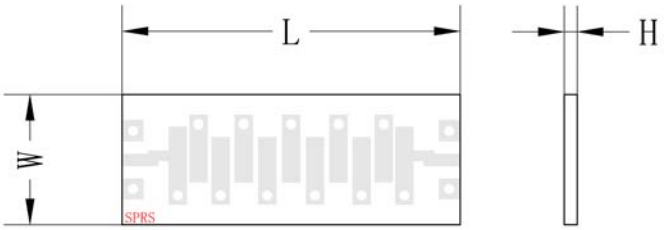
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	30.9	GHz
工作带宽	30.0-31.8	GHz
中心损耗	2.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	50@DC-27.6GHz	dBc
带外抑制	40@33.5-47.0GHz	dBc

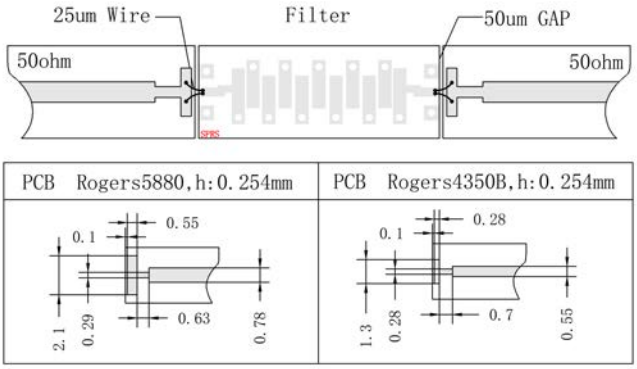
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：6.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

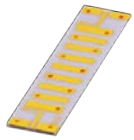
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

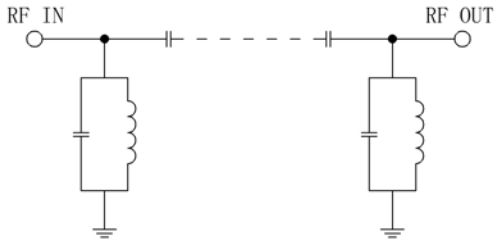
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

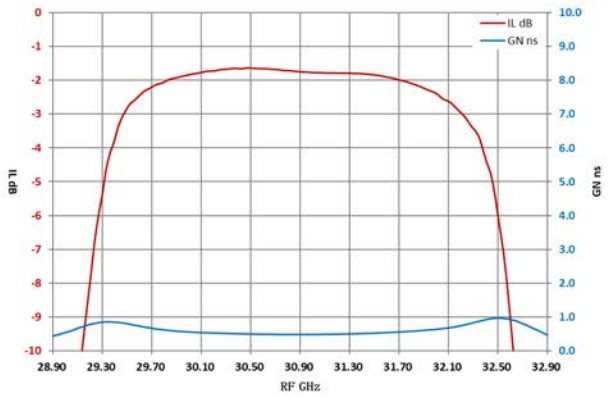
参考图

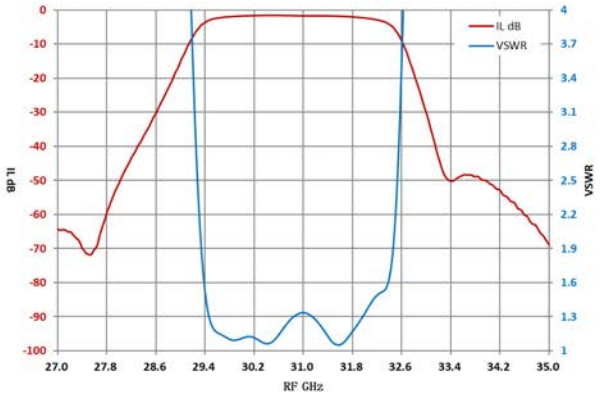


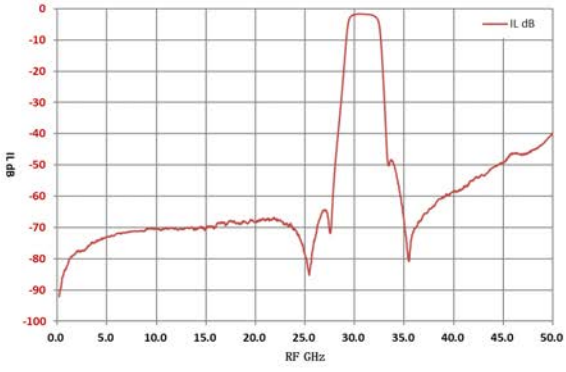
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

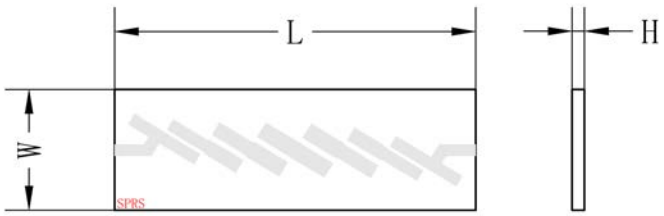
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	32.2	GHz
工作带宽	30.0-34.4	GHz
中心损耗	1.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	35@DC-27.8GHz	dBc
带外抑制	35@37.2-42.0GHz	dBc

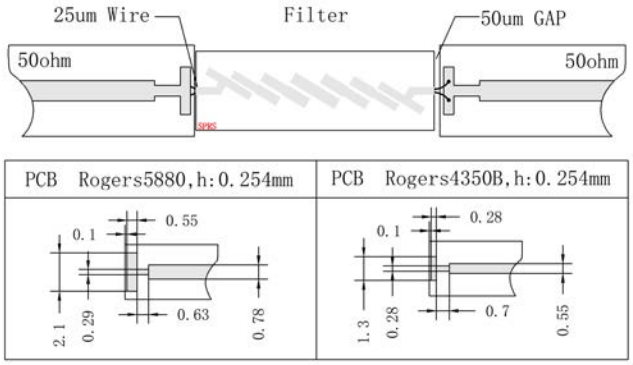
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：6.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

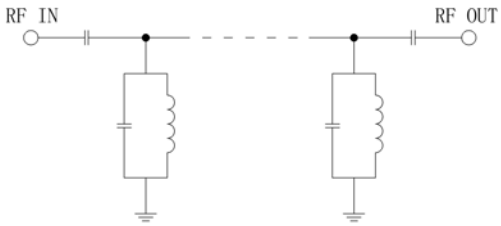
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

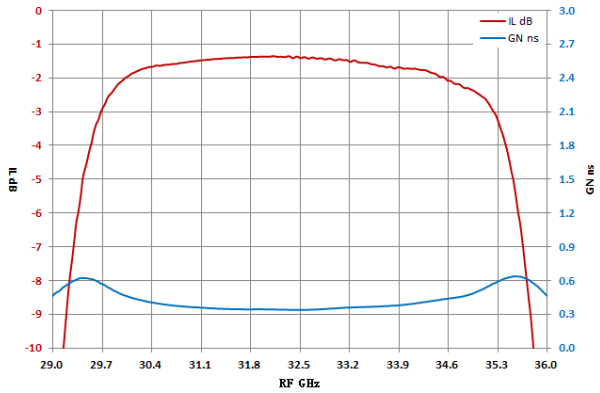
参考图

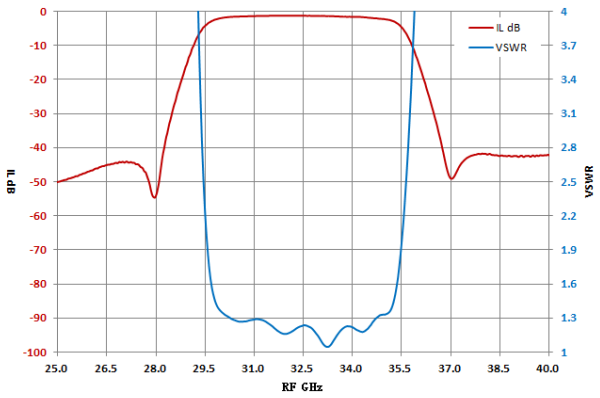


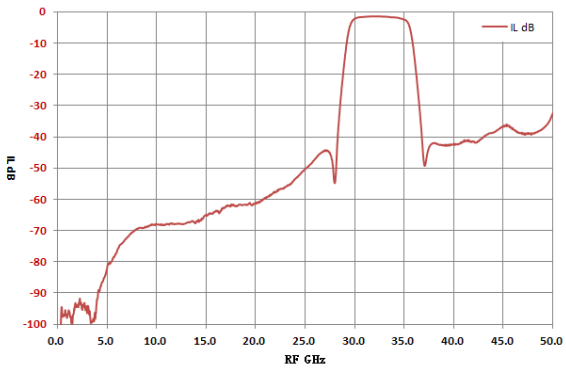
原理图



典型曲线







陶瓷滤波器 STBP324-4R8-X420

工作带宽 30.0-34.8GHz,带外抑制 40@DC-27.5GHz,40@37.6-45.0GHz

产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



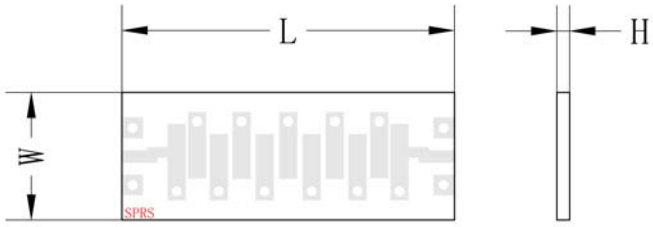
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	32.4	GHz
工作带宽	30.0-34.8	GHz
中心损耗	3.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-27.5GHz	dBc
带外抑制	40@37.6-45.0GHz	dBc

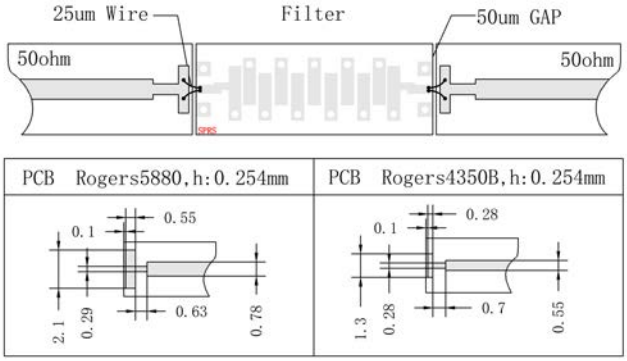
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



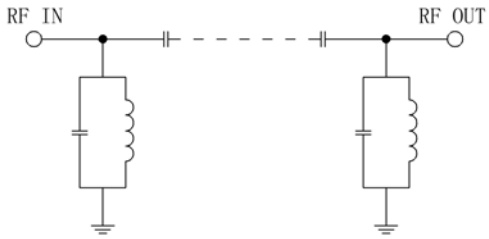
推荐装配图



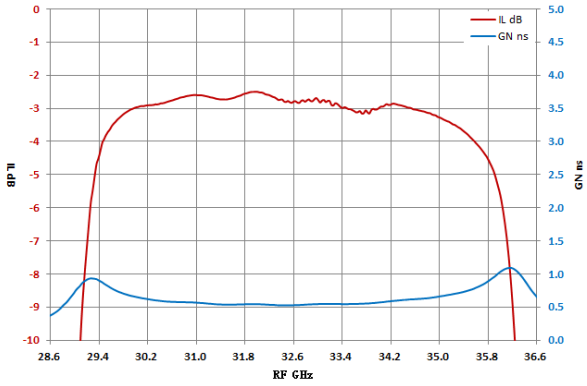
注意事项

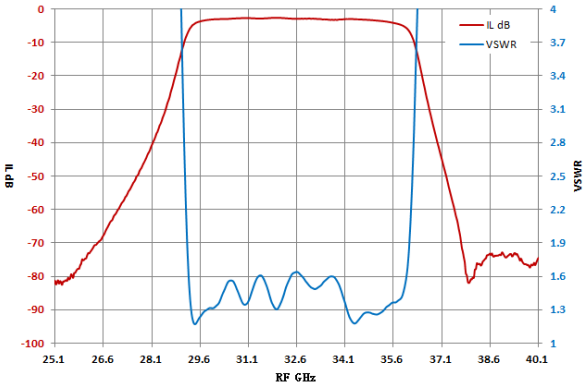
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

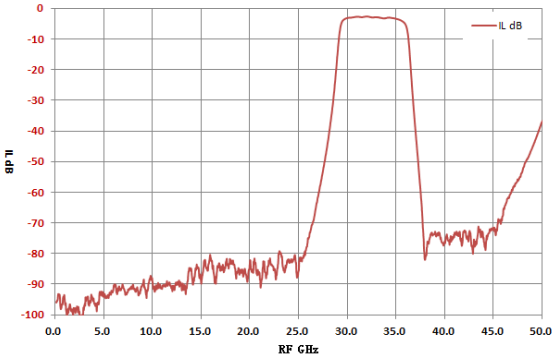
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



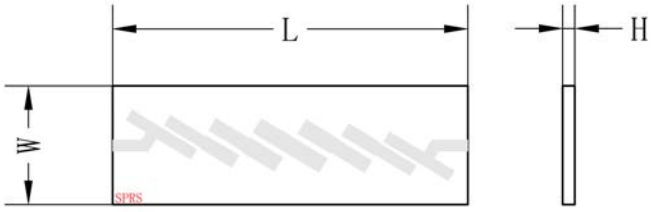
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	32.5	GHz
工作带宽	30.0-35.0	GHz
中心损耗	1.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-27.8GHz	dBc
带外抑制	40@37.5-45.0GHz	dBc

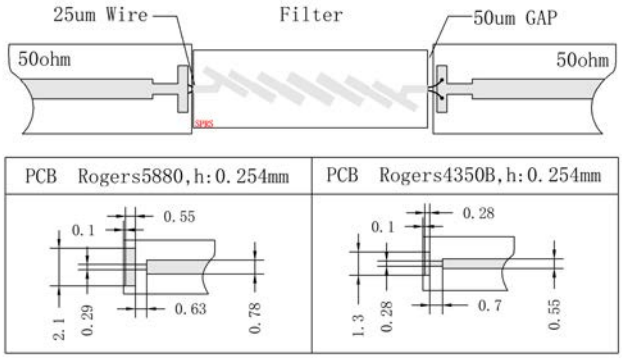
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



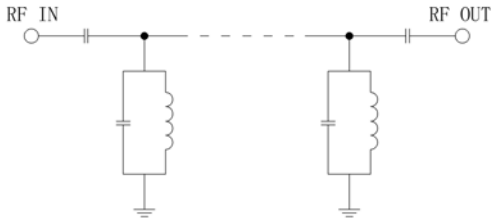
推荐装配图



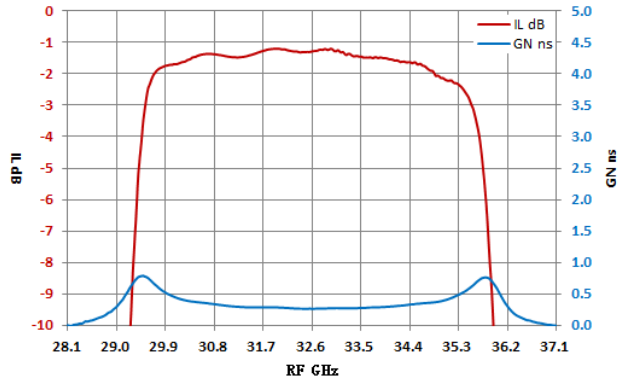
注意事项

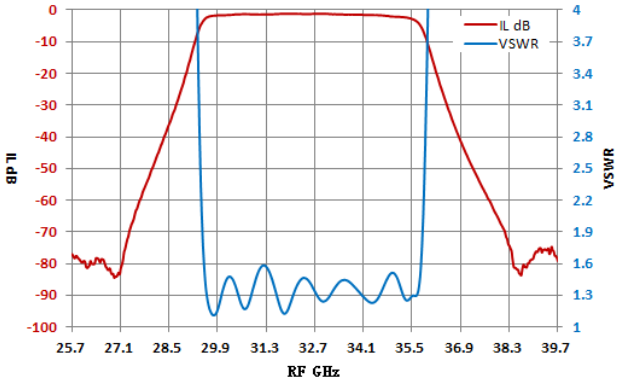
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

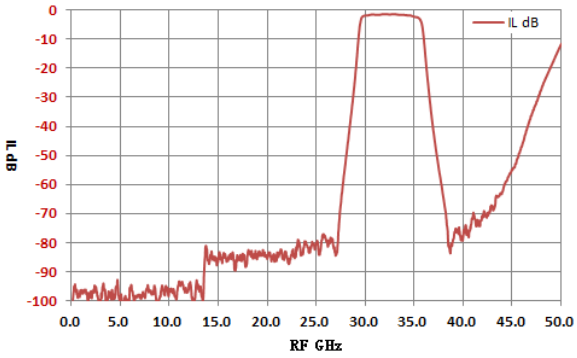
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



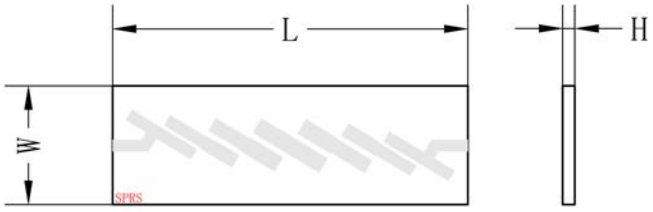
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	34.5	GHz
工作带宽	30.0-39.0	GHz
中心损耗	1.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-26.7GHz	dBc
带外抑制	40@43.0-51.0GHz	dBc

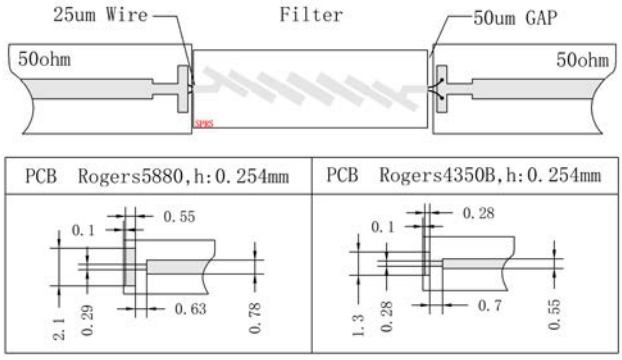
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：1.9，h：0.26

外形图：端口居中



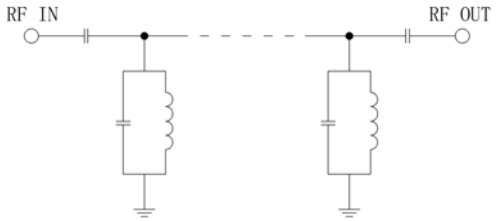
推荐装配图



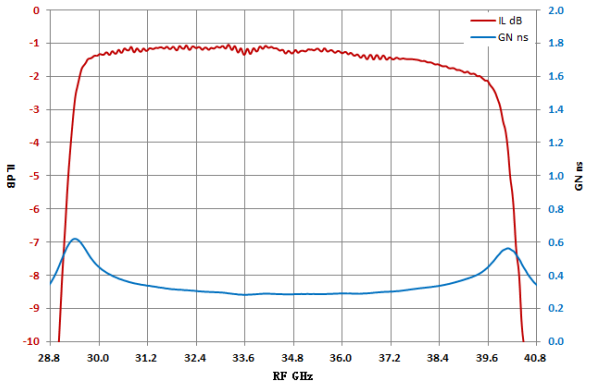
注意事项

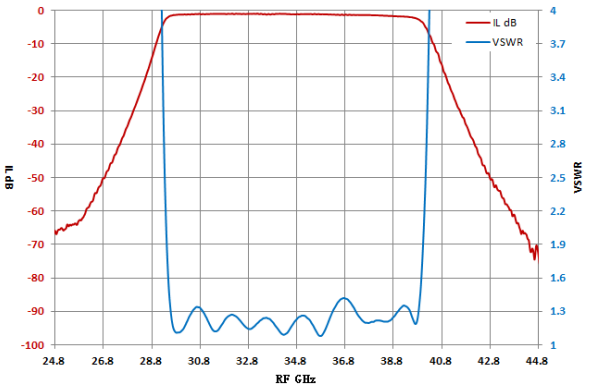
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

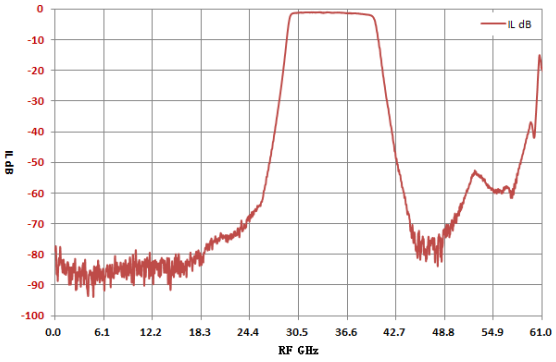
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



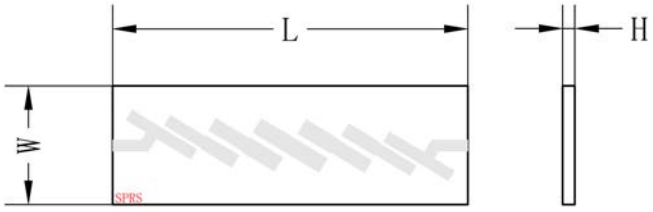
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	30.7	GHz
工作带宽	30.1-31.3	GHz
中心损耗	3.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-28.8GHz	dBc
带外抑制	40@32.8-41.0GHz	dBc

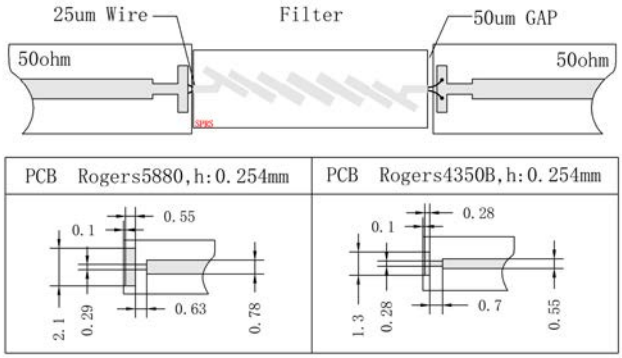
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：10.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



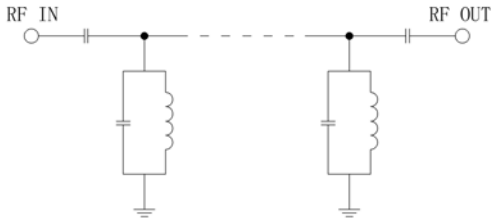
推荐装配图



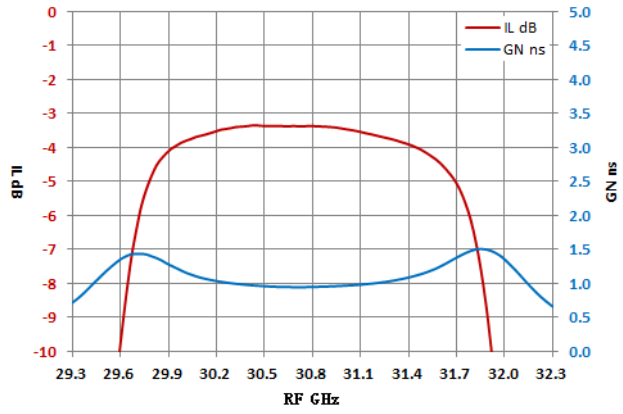
注意事项

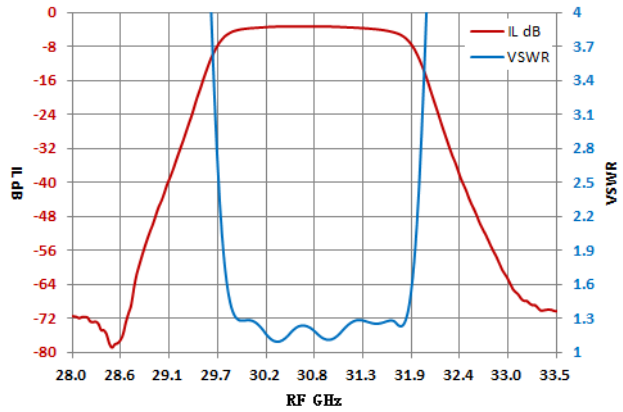
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

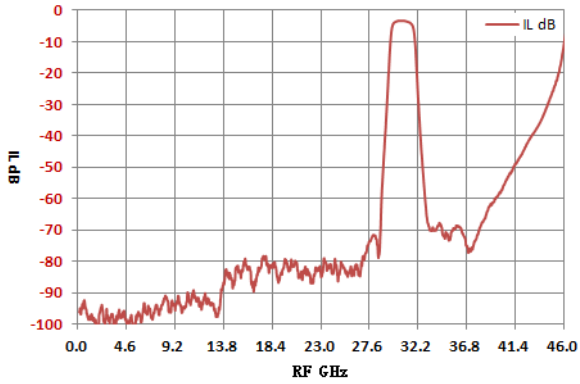
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



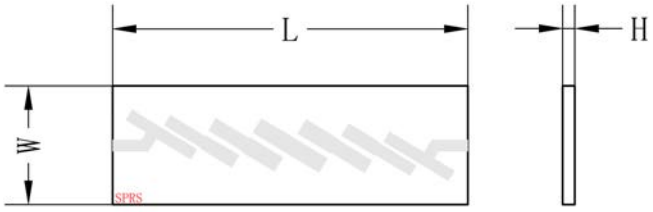
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	32.0	GHz
工作带宽	30.2-33.8	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-28.0GHz	dBc
带外抑制	40@37.0-45.0GHz	dBc

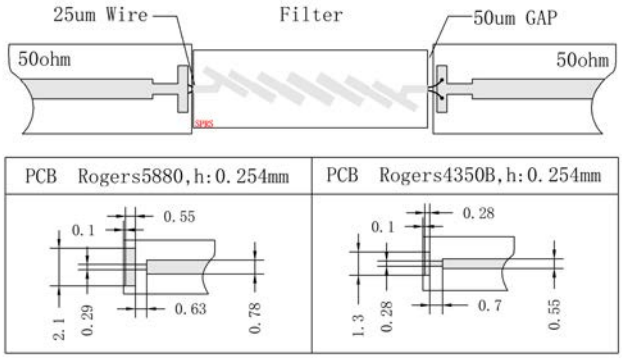
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



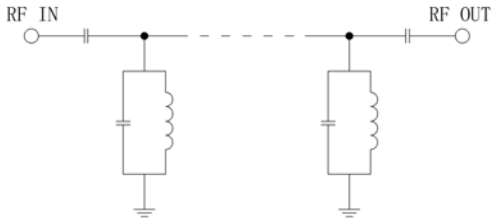
推荐装配图



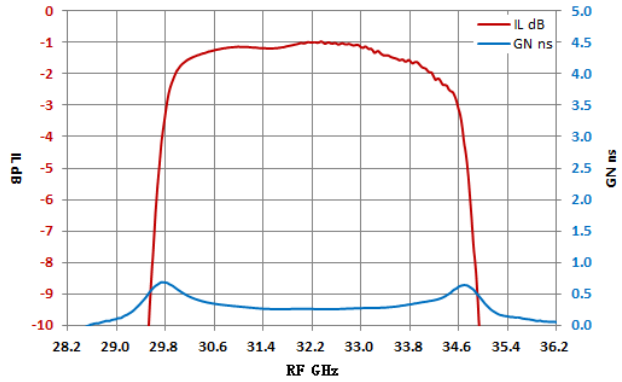
注意事项

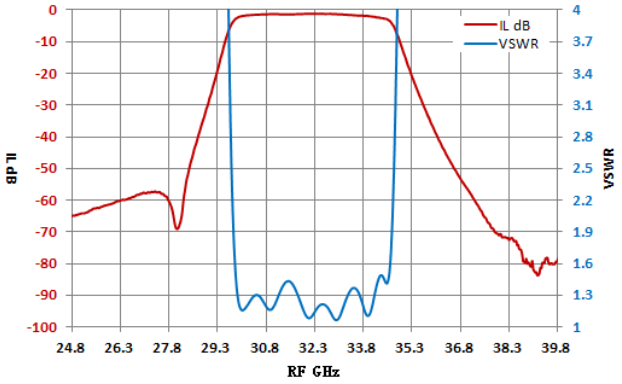
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

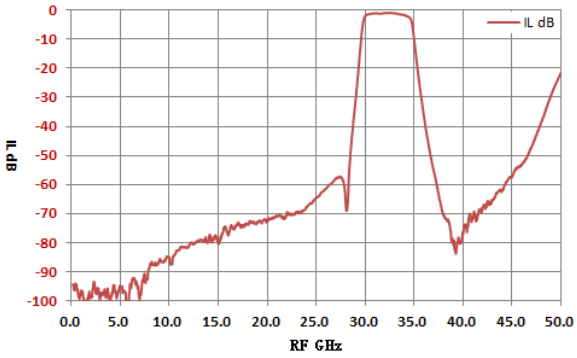
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



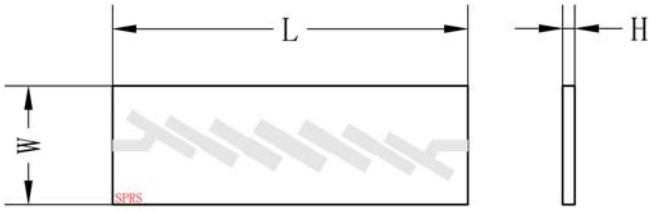
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	35.2	GHz
工作带宽	30.2-40.2	GHz
中心损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-26.1GHz	dBc
带外抑制	40@44.9-53.0GHz	dBc

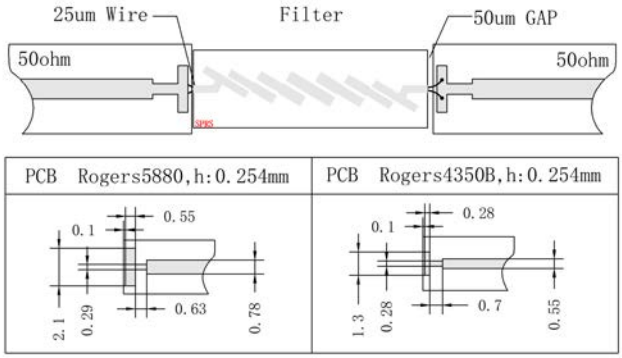
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



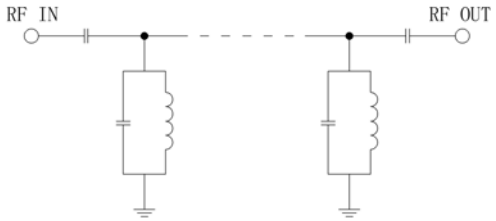
推荐装配图



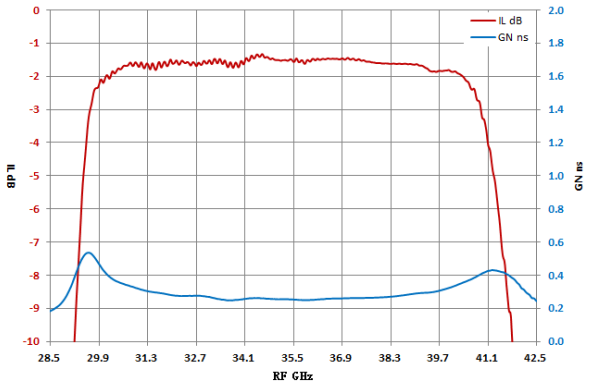
注意事项

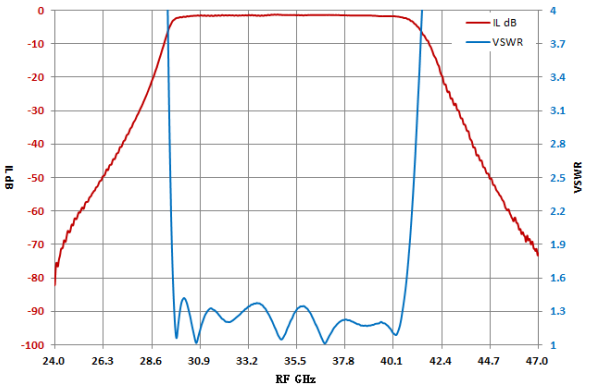
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

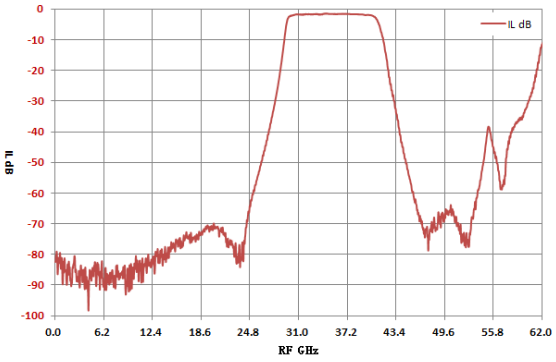
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

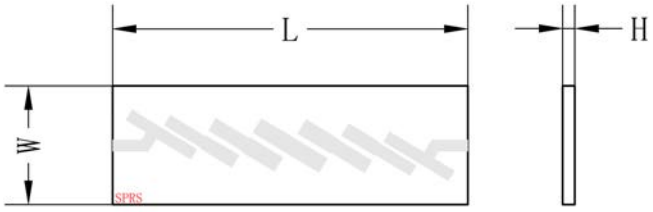
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	32.4	GHz
工作带宽	30.7-34.1	GHz
中心损耗	2.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-28.8GHz	dBc
带外抑制	40@37.1-45.0GHz	dBc

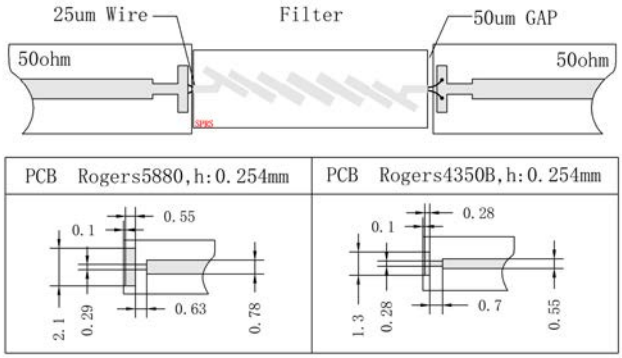
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



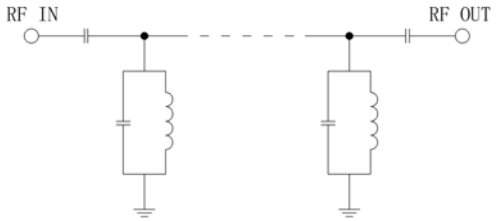
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

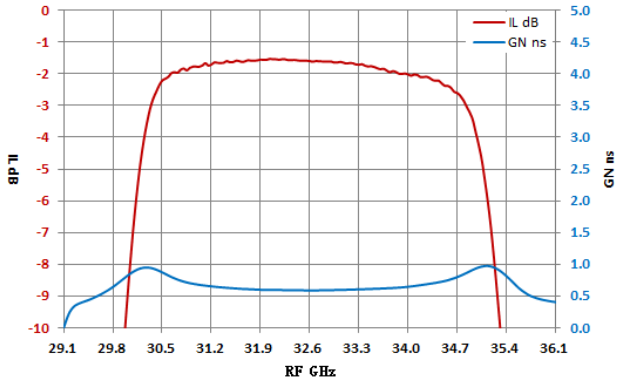
参考实物图

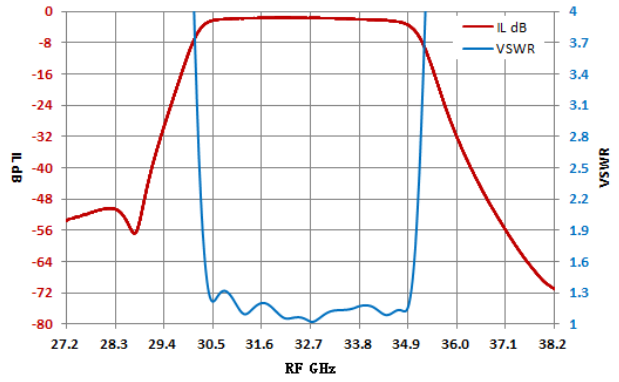


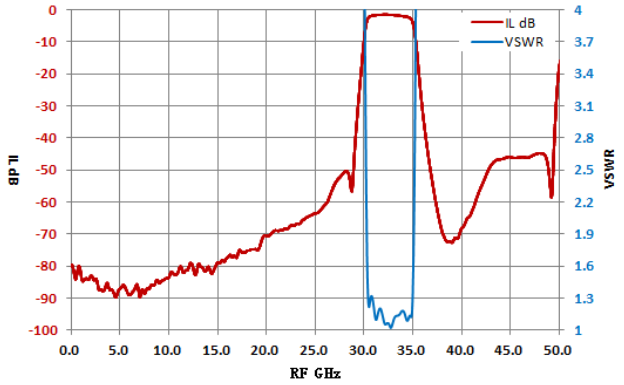
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

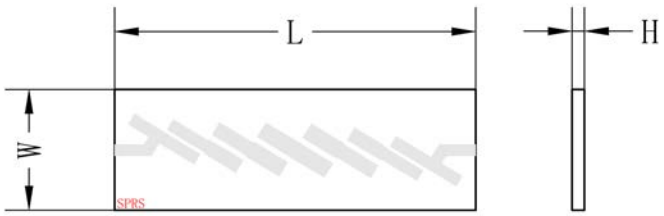
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	32.8	GHz
工作带宽	30.8-34.8	GHz
中心损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.8:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	50@DC-28.6GHz	dBc
带外抑制	40@37.4-47.0GHz	dBc

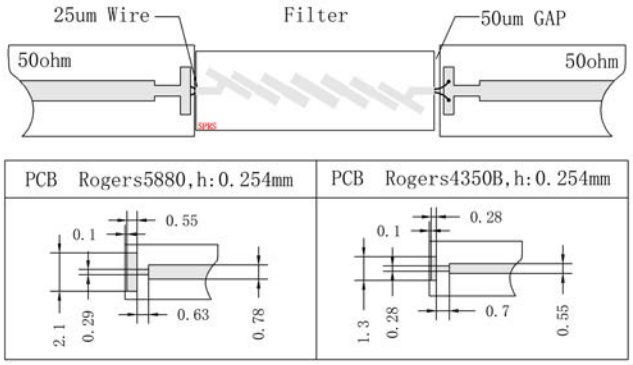
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：9.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

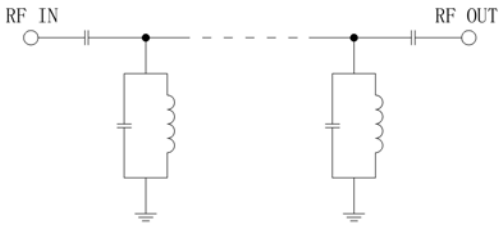
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

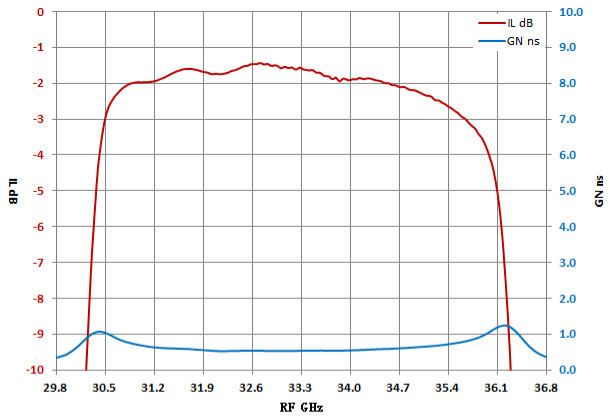
参考图

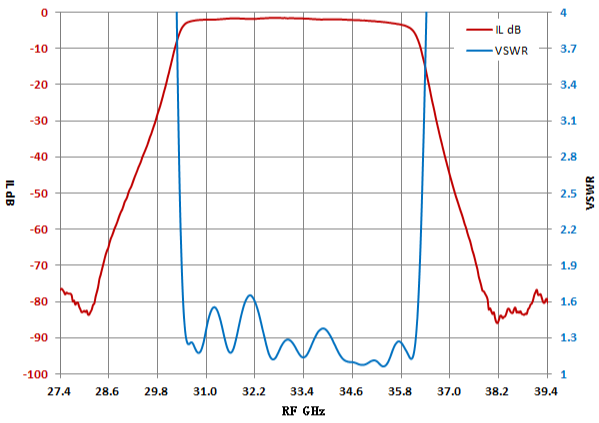


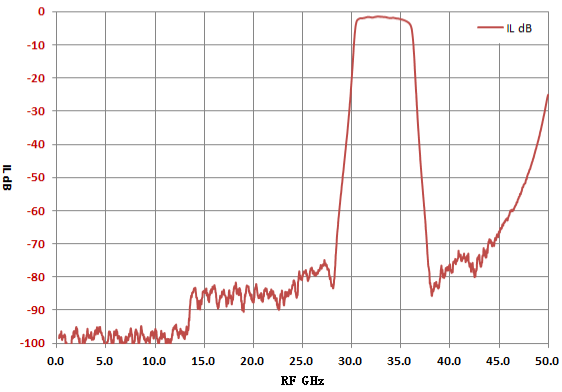
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



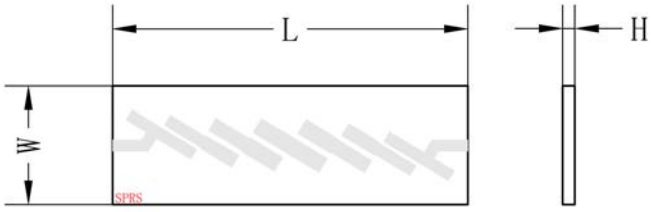
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	33.4	GHz
工作带宽	30.8-36.0	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-28.8GHz	dBc
带外抑制	40@38.2-45.0GHz	dBc

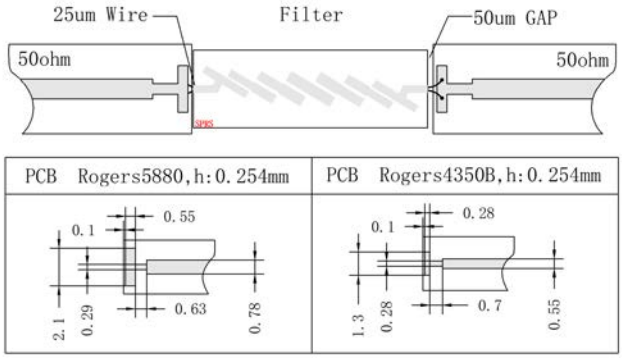
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



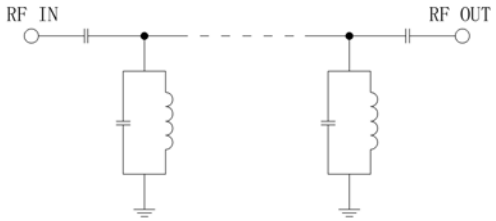
推荐装配图



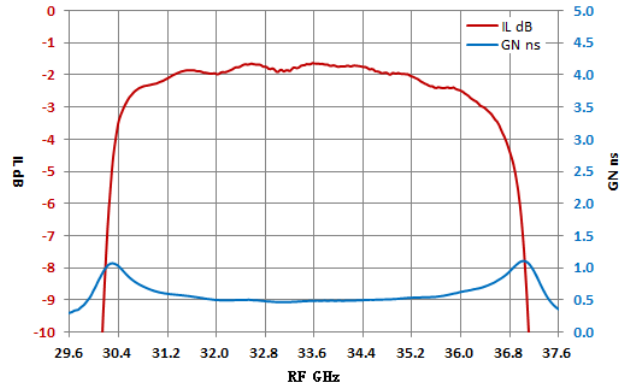
注意事项

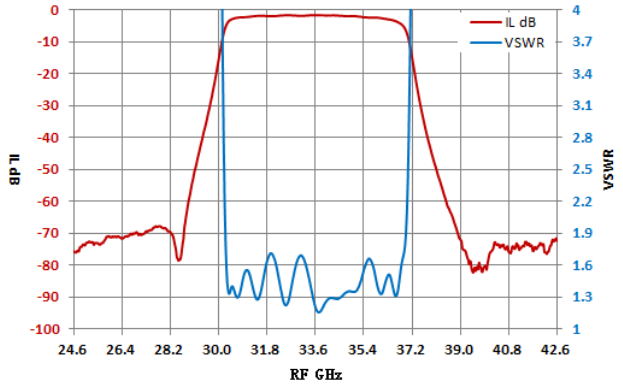
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

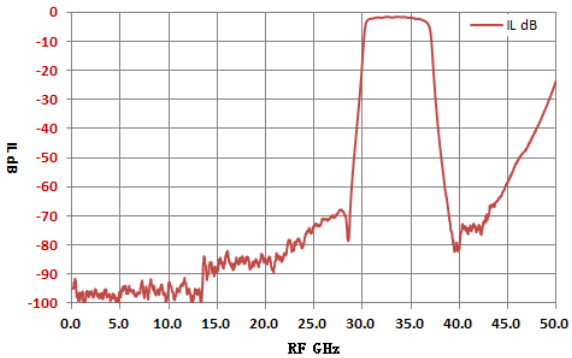
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

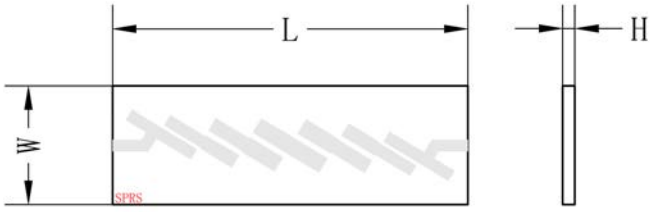
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	32.7	GHz
工作带宽	30.9-34.5	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-28.9GHz	dBc
带外抑制	40@37.0-45.0GHz	dBc

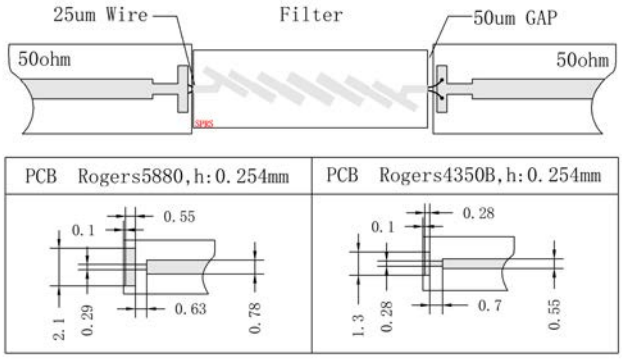
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



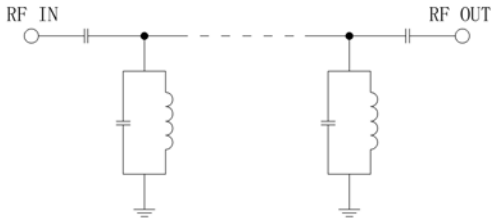
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

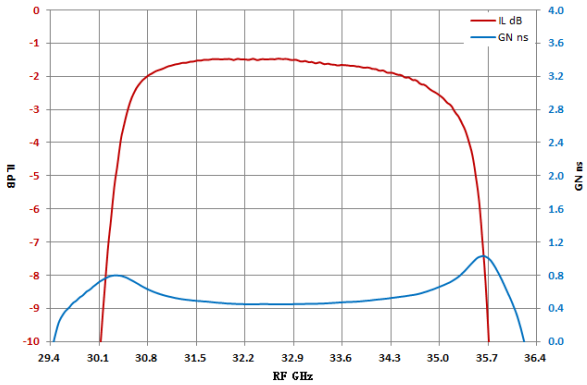
参考实物图

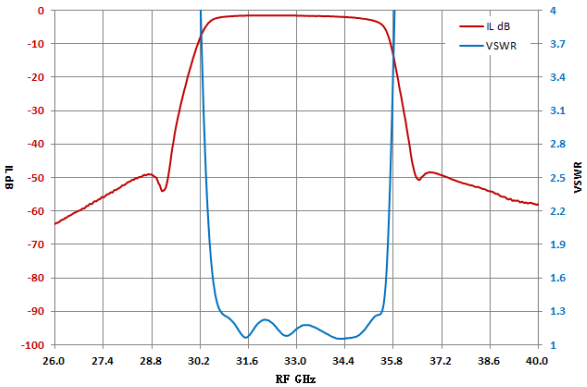


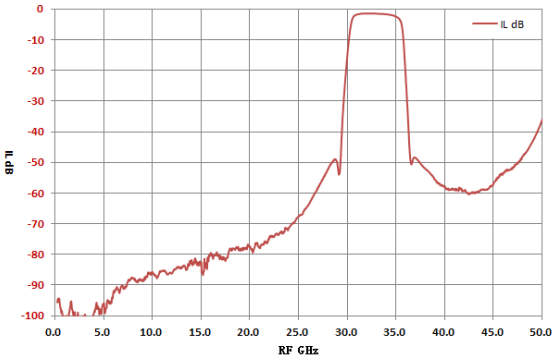
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



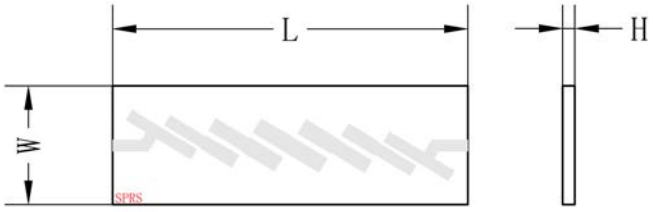
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	34.1	GHz
工作带宽	30.9-37.3	GHz
中心损耗	2.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-28.8GHz	dBc
带外抑制	40@39.4-45.0GHz	dBc

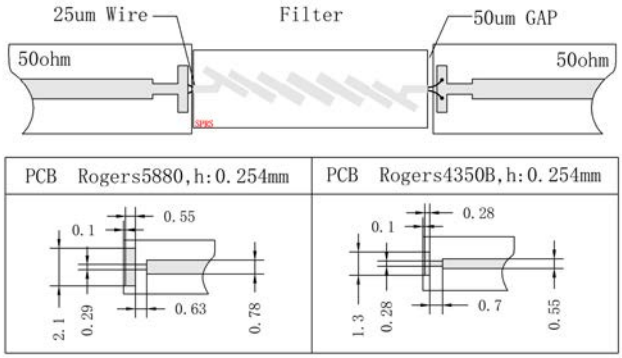
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



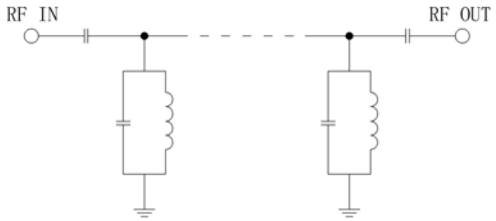
推荐装配图



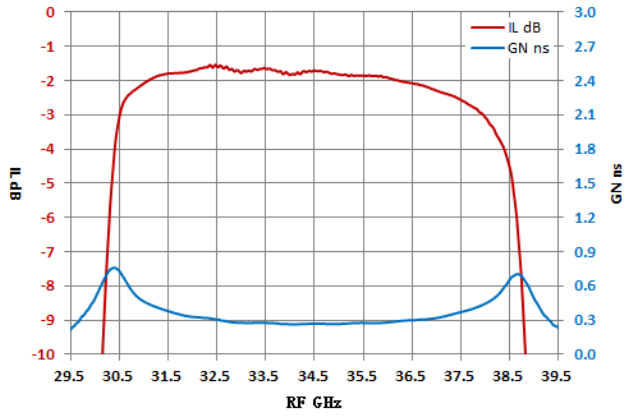
注意事项

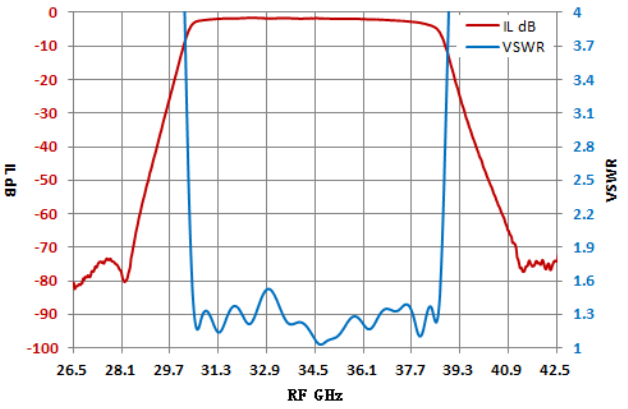
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

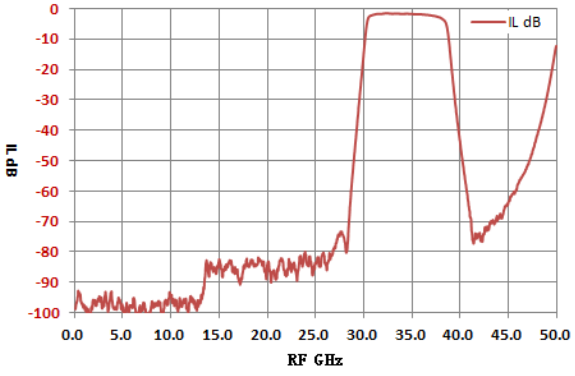
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



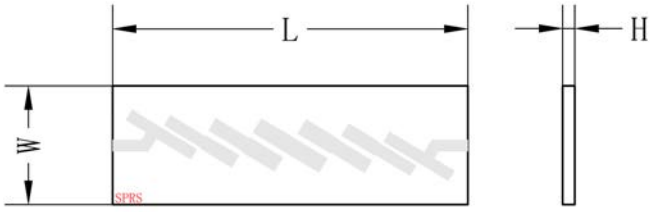
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	34.2	GHz
工作带宽	31.2-37.2	GHz
中心损耗	1.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-29.3GHz	dBc
带外抑制	40@39.8-49.0GHz	dBc

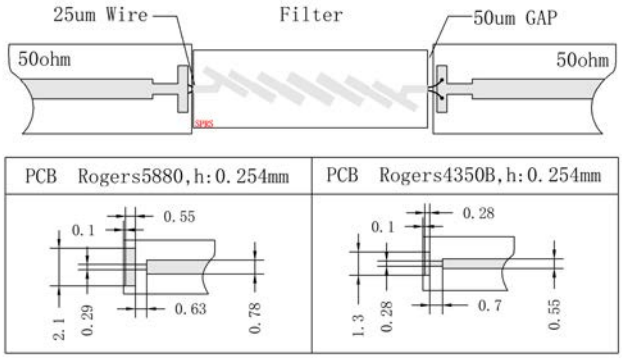
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



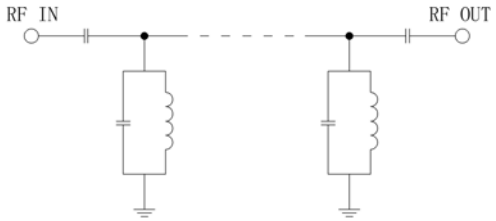
推荐装配图



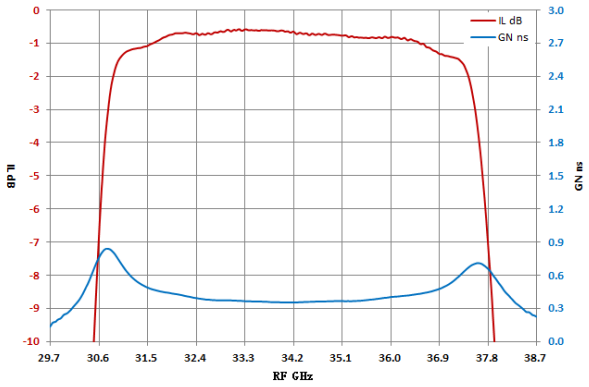
注意事项

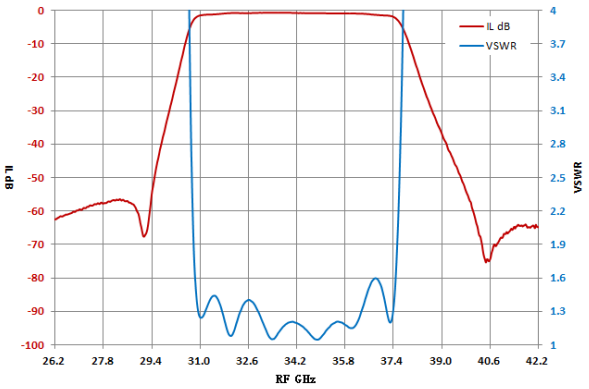
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

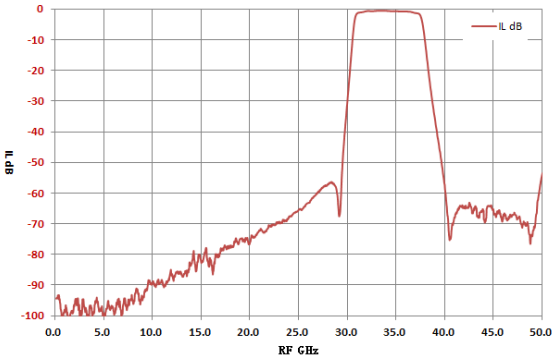
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

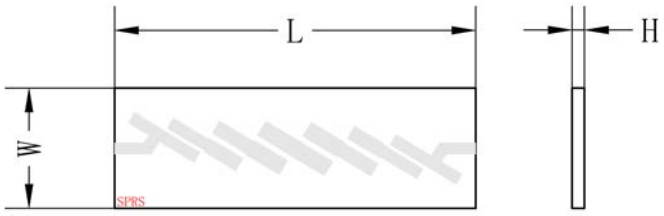
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	34.2	GHz
工作带宽	31.3-37.1	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-29.0GHz	dBc
带外抑制	40@39.9-44.0GHz	dBc

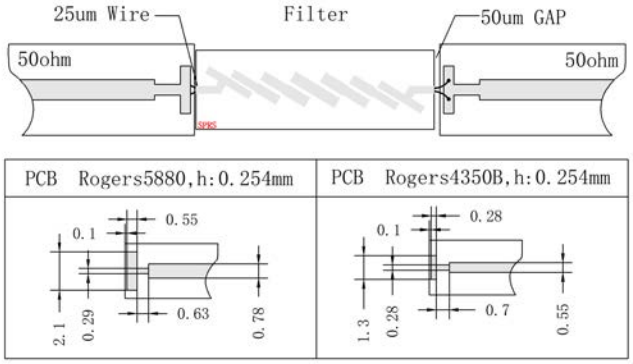
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：9.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

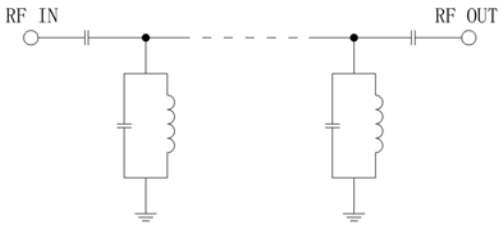
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

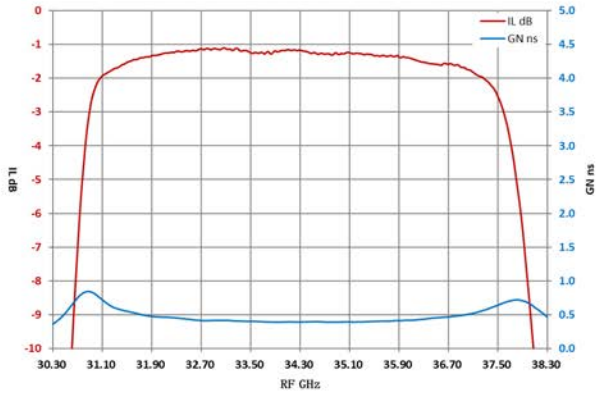
参考图

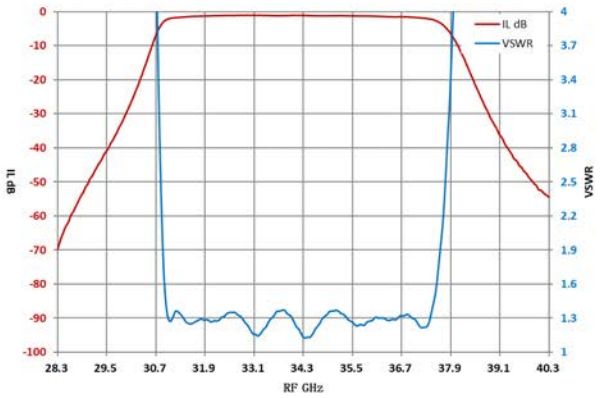


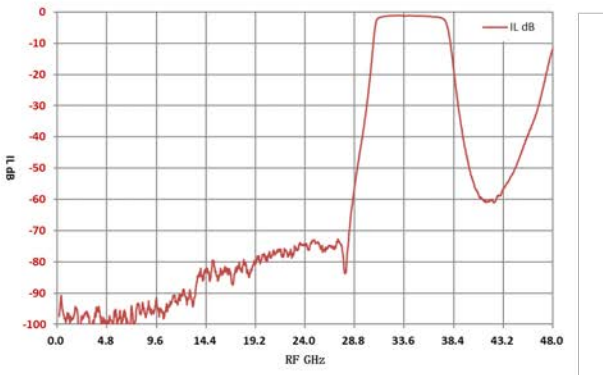
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

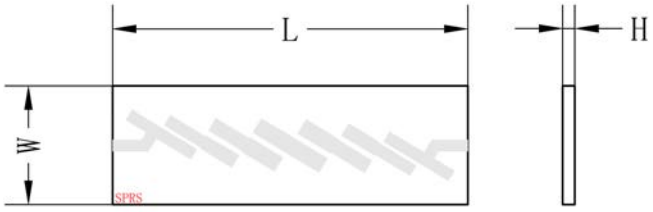
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	33.7	GHz
工作带宽	31.4-36.0	GHz
中心损耗	2.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-29.0GHz	dBc
带外抑制	40@38.5-48.0GHz	dBc

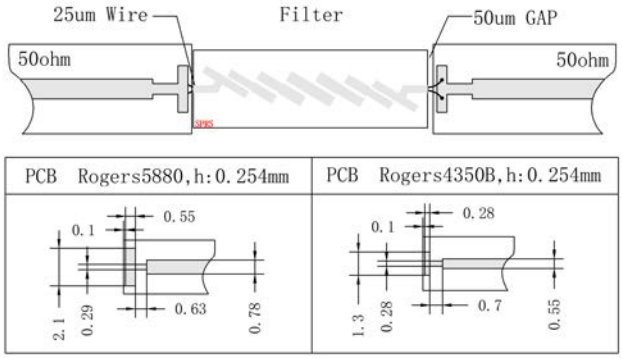
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



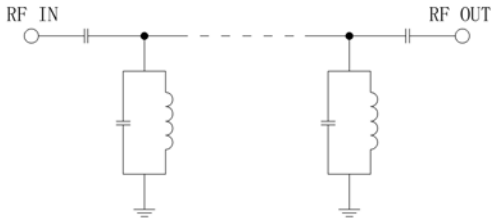
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

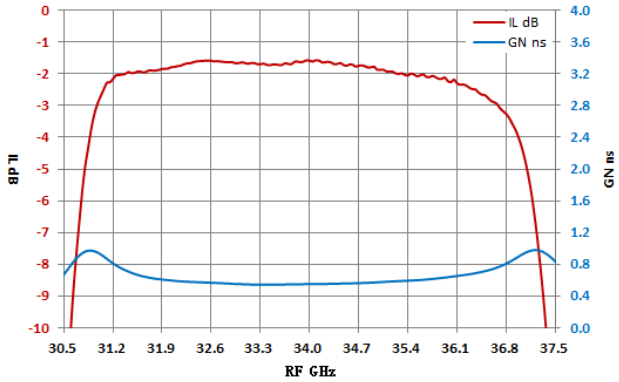
参考实物图

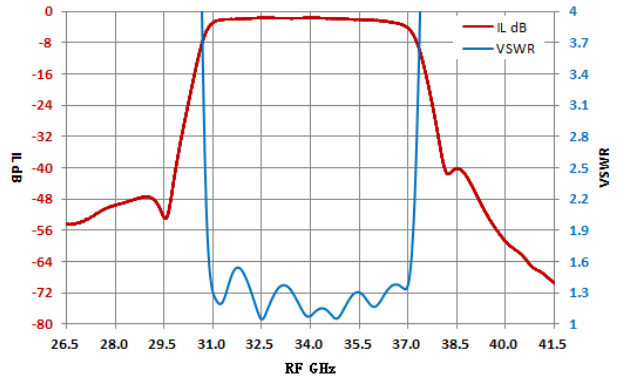


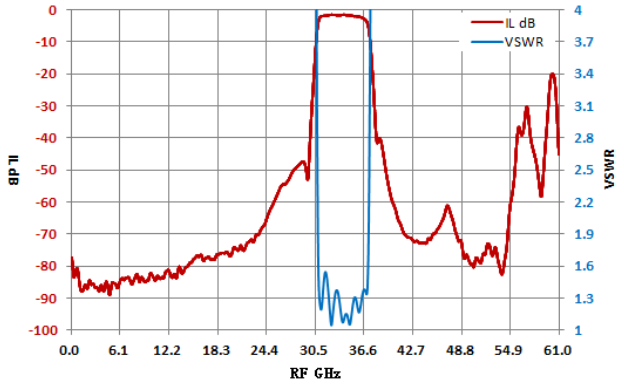
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

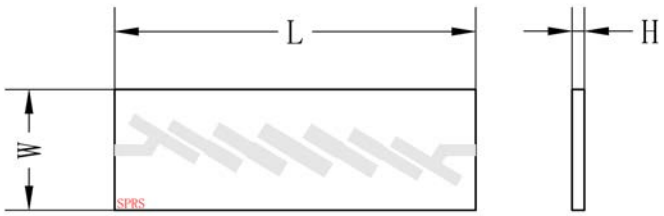
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	33.5	GHz
工作带宽	31.5-35.5	GHz
中心损耗	1.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	35@DC-29.0GHz	dBc
带外抑制	35@38.4-46.0GHz	dBc

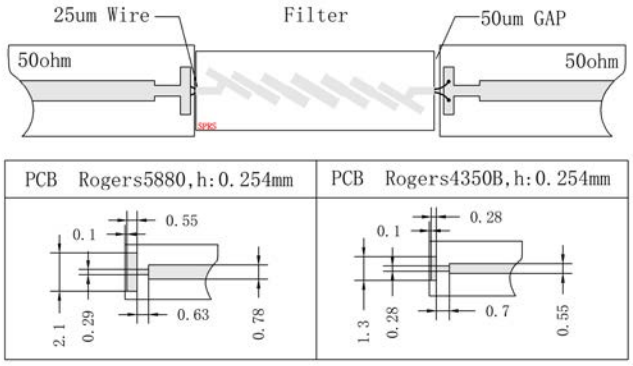
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：5.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

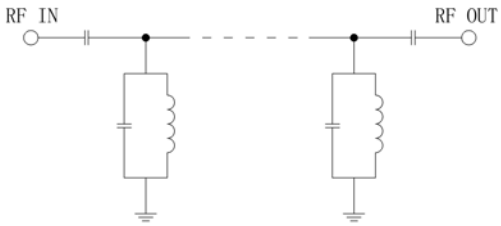
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

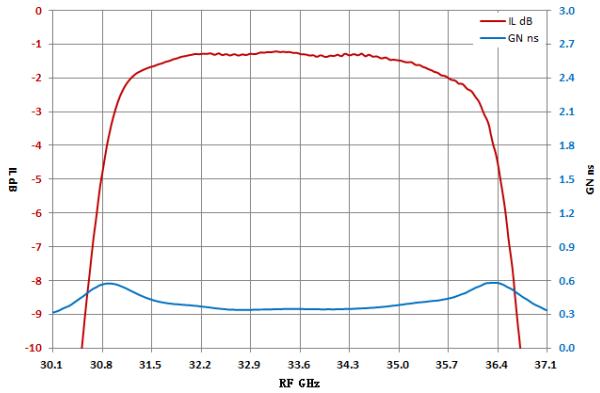
参考图

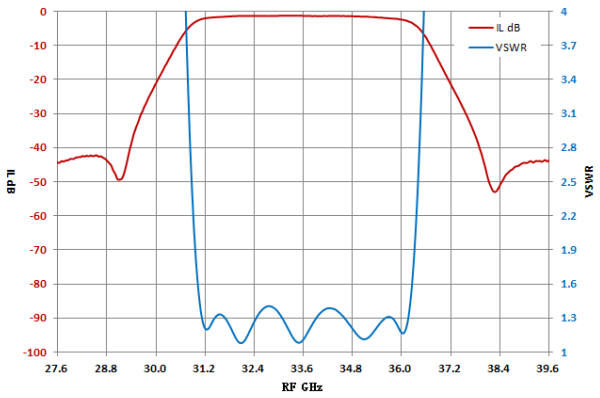


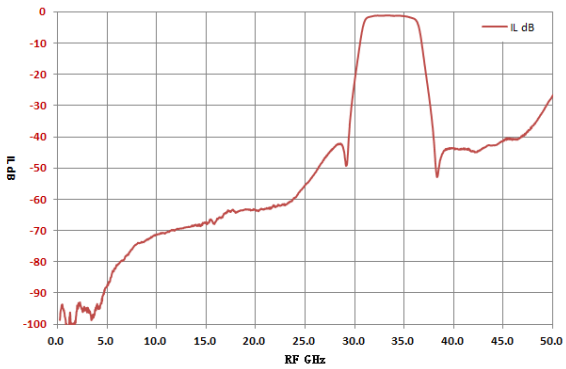
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

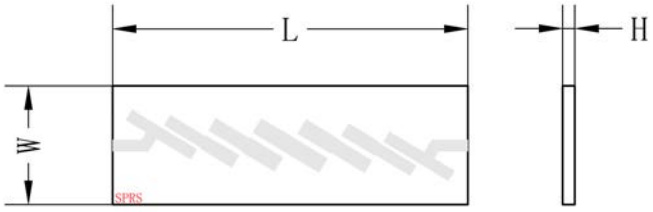
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	35.25	GHz
工作带宽	31.5-39.0	GHz
中心损耗	1.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-26.3GHz	dBc
带外抑制	40@45.0-50.0GHz	dBc

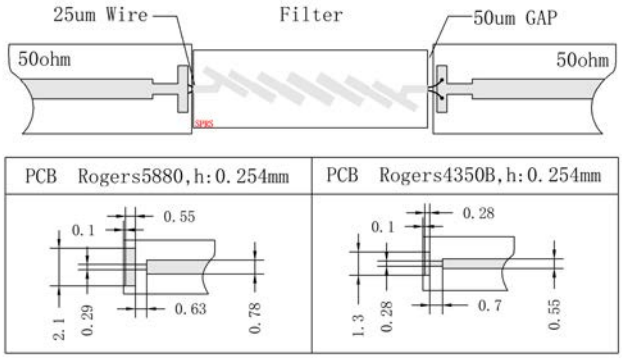
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：1.9，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



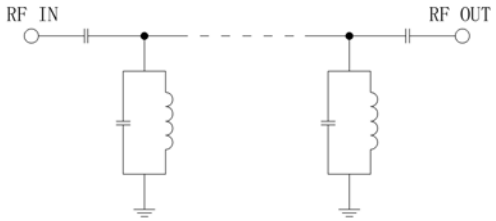
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

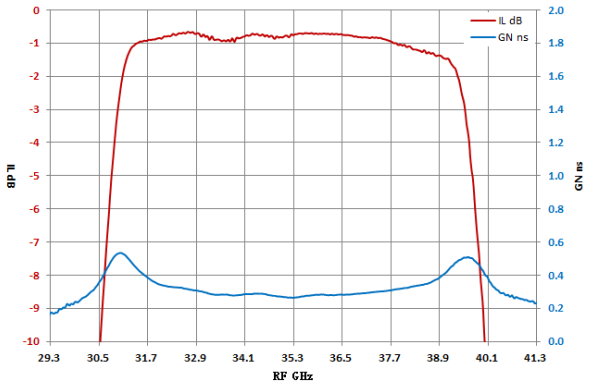
参考实物图

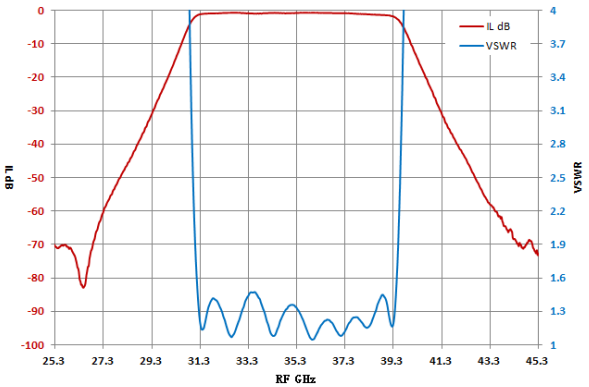


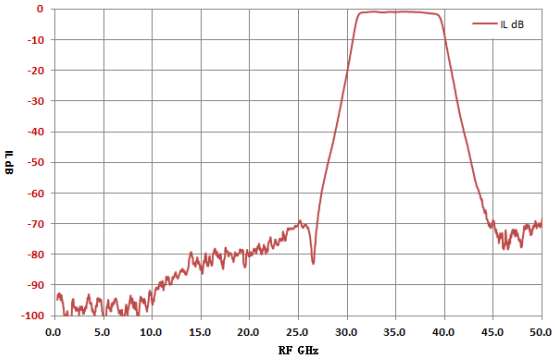
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

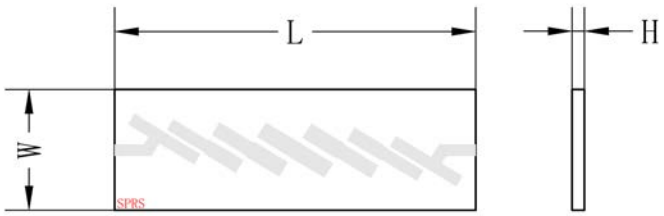
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	32.1	GHz
工作带宽	31.6-32.6	GHz
中心损耗	3.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-30.1GHz	dBc
带外抑制	45@34.2-41.0GHz	dBc

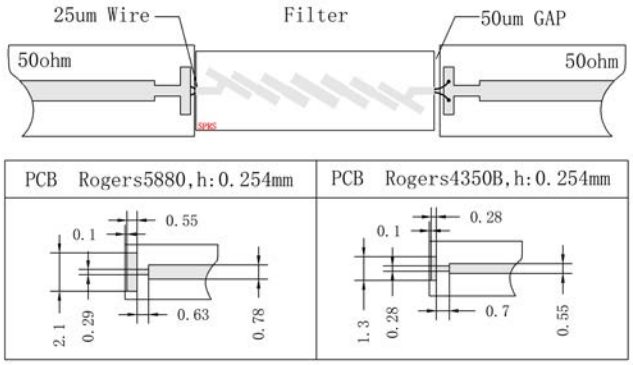
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：6.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

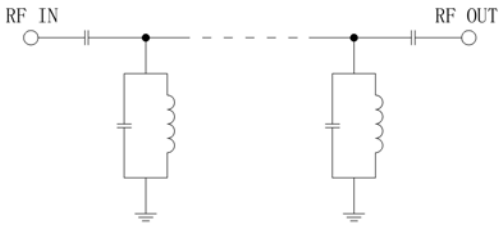
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

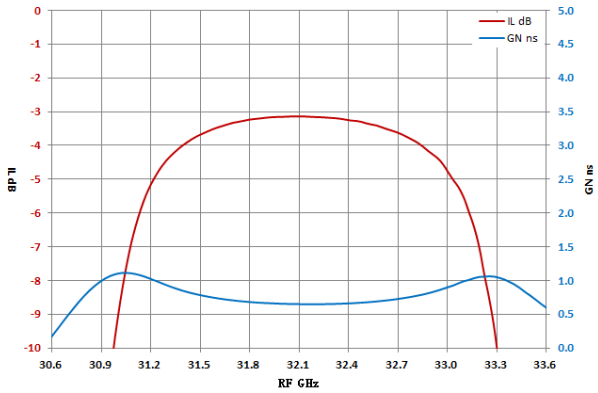
参考图

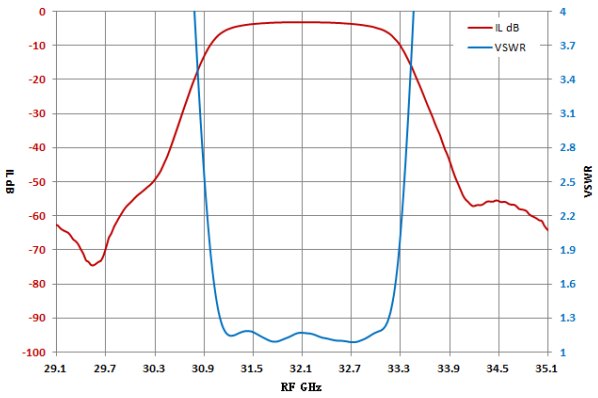


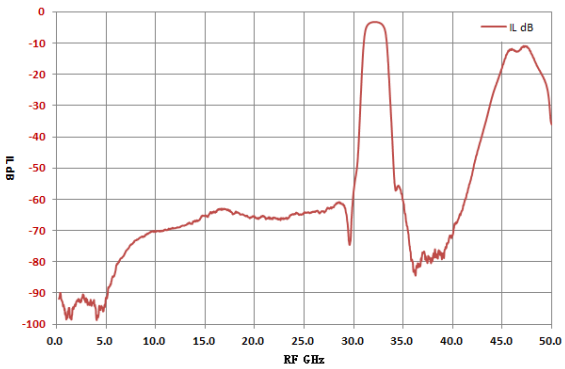
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



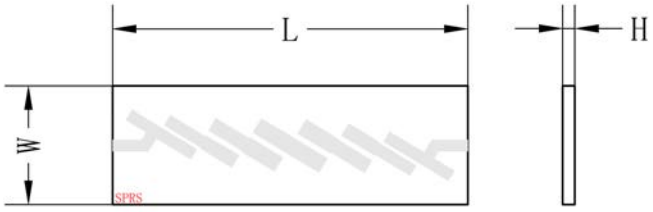
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	37.4	GHz
工作带宽	31.6-43.2	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-26.9GHz	dBc
带外抑制	40@49.0-54.0GHz	dBc

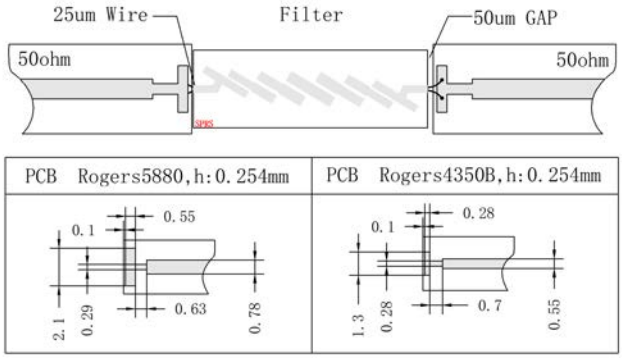
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



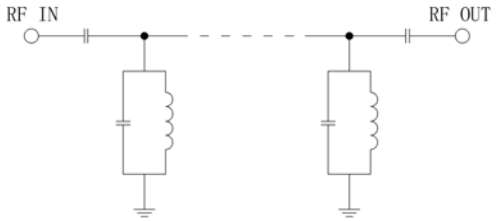
推荐装配图



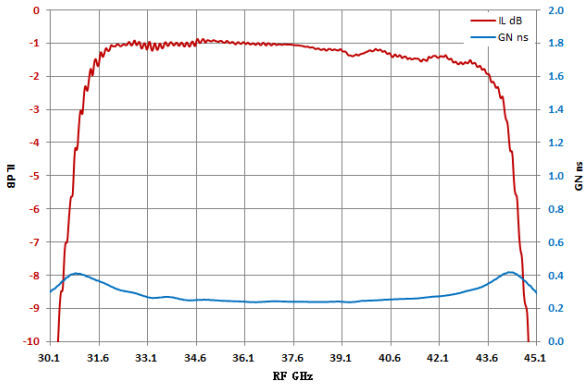
注意事项

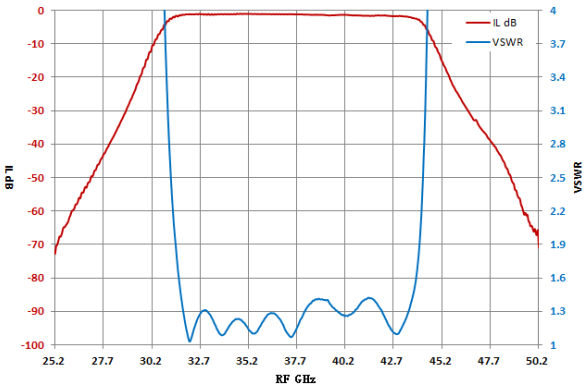
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

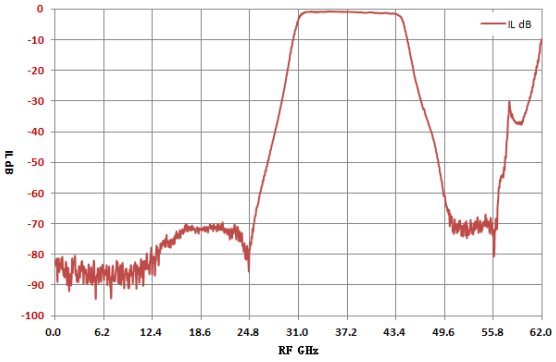
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



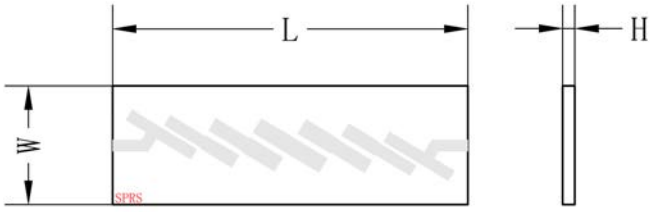
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	38.1	GHz
工作带宽	31.6-44.6	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-27.6GHz	dBc
带外抑制	40@52.5-59.0GHz	dBc

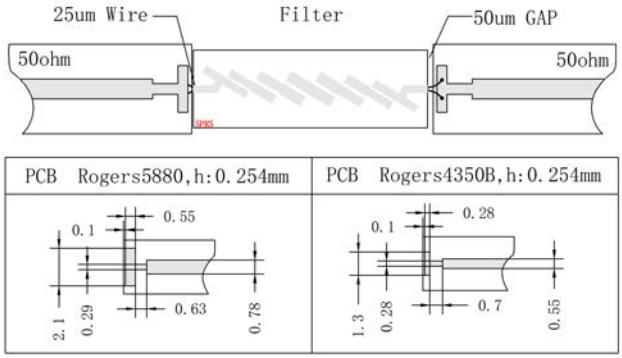
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



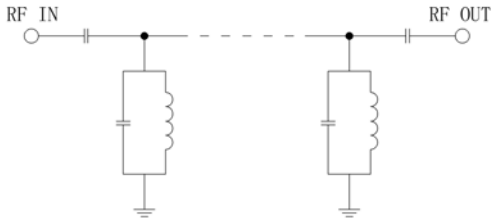
推荐装配图



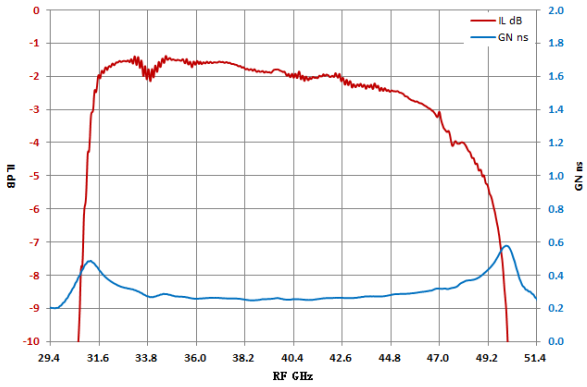
注意事项

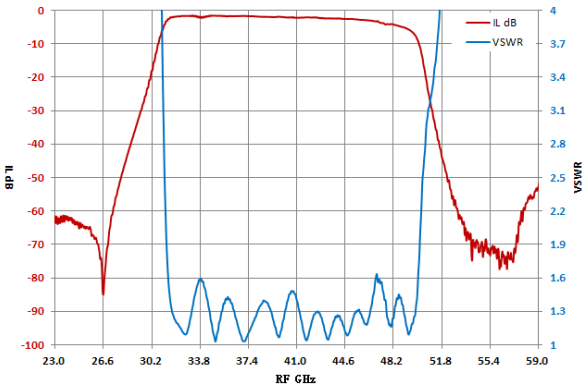
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

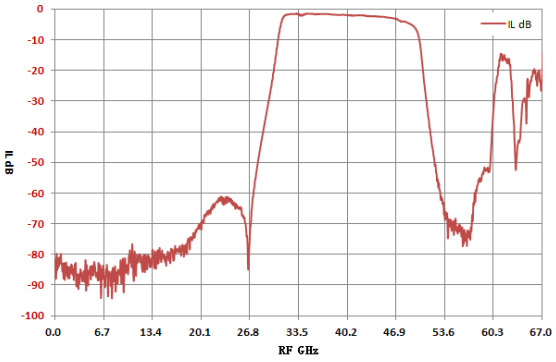
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

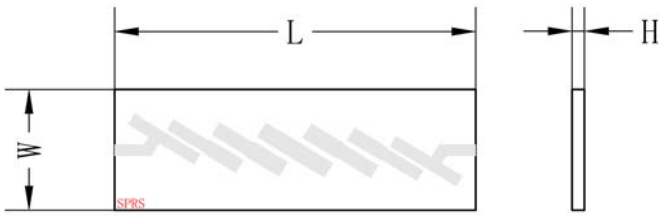
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	32.5	GHz
工作带宽	31.7-33.3	GHz
中心损耗	2.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-29.9GHz	dBc
带外抑制	40@35.1-45.0GHz	dBc

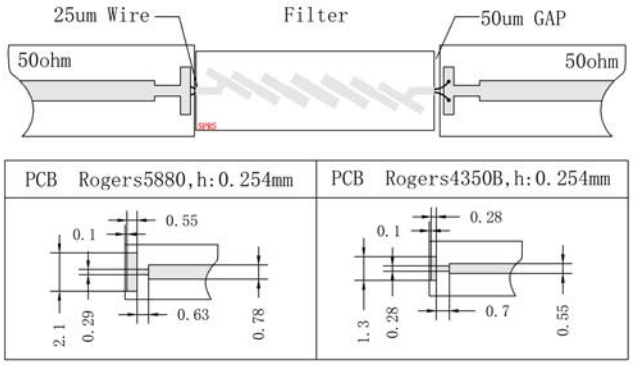
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：6.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

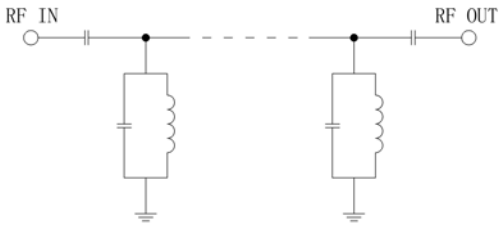
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

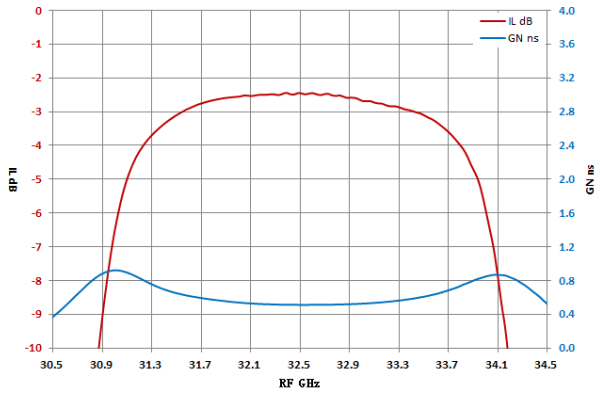
参考图

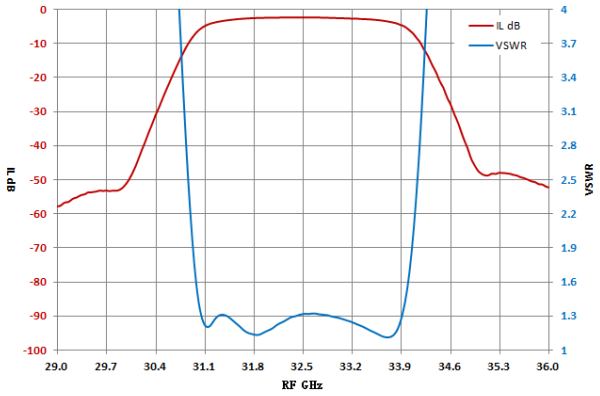


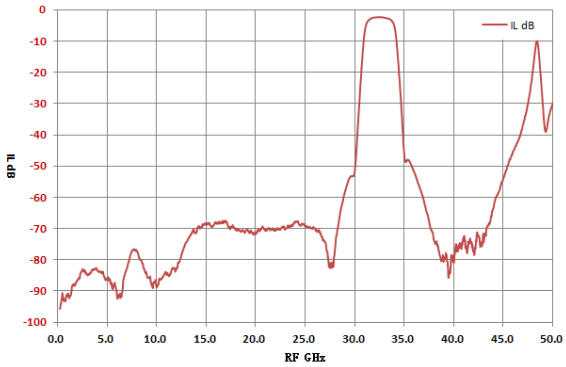
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



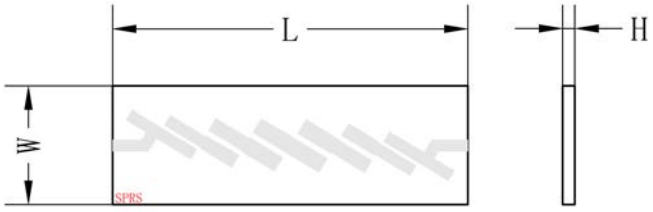
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	36.0	GHz
工作带宽	31.7-40.3	GHz
中心损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-29.4GHz	dBc
带外抑制	40@44.0-54.0GHz	dBc

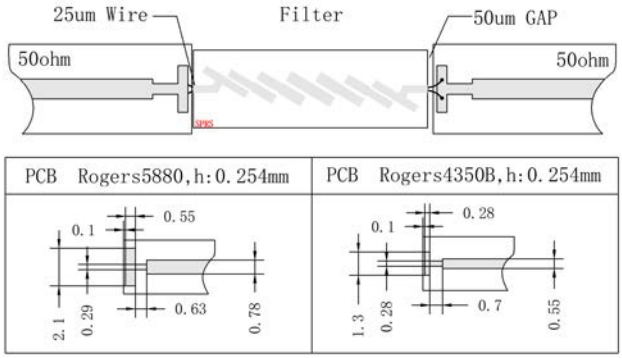
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



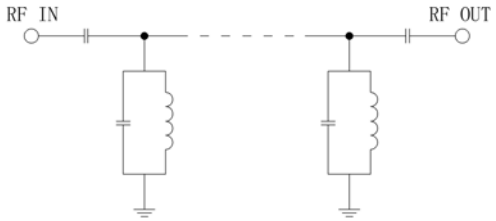
推荐装配图



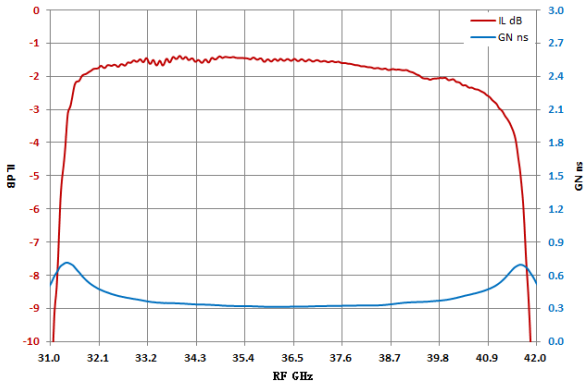
注意事项

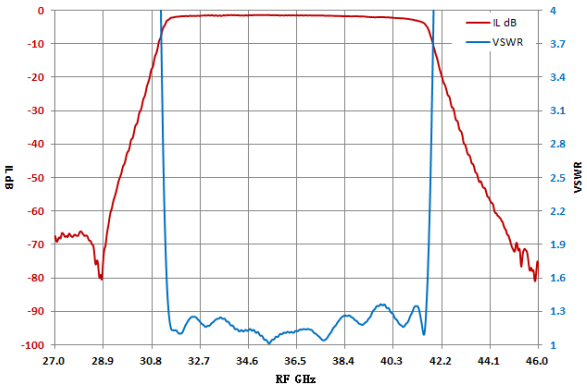
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

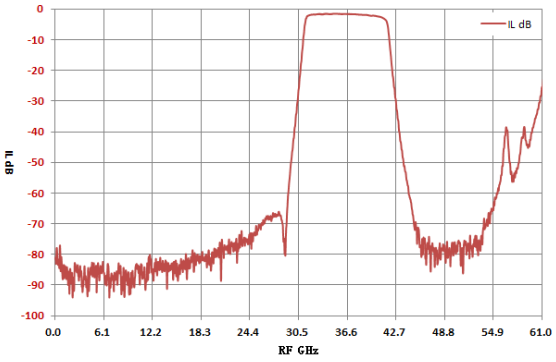
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



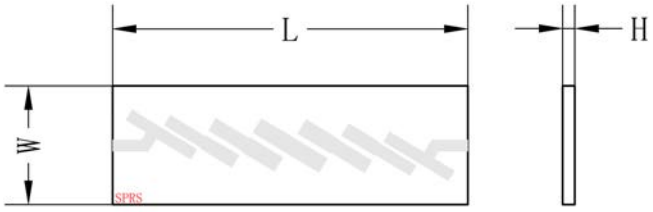
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	35.9	GHz
工作带宽	31.8-40.0	GHz
中心损耗	1.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-29.0GHz	dBc
带外抑制	40@44.0-55.0GHz	dBc

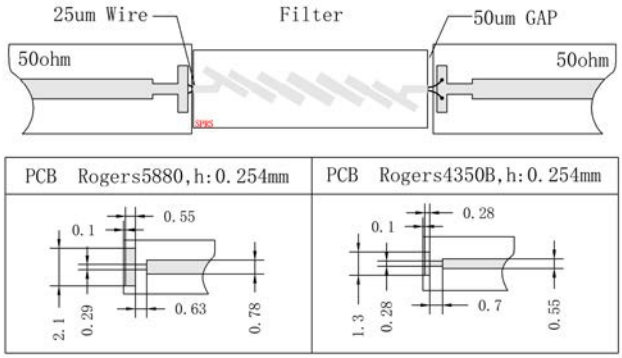
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



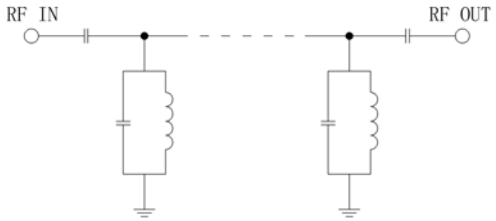
推荐装配图



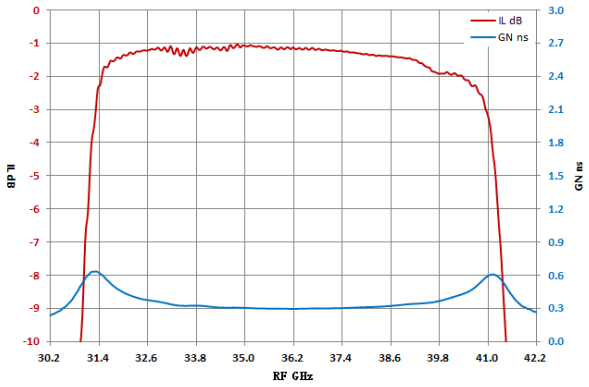
注意事项

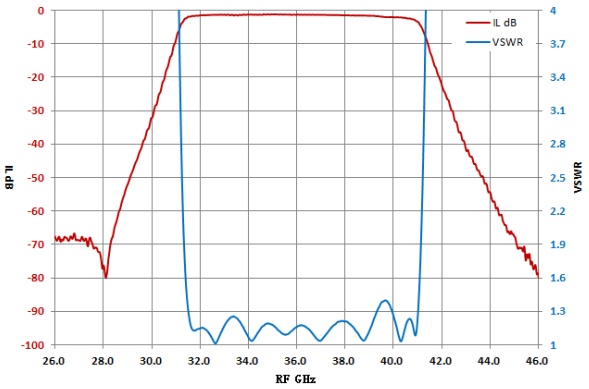
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

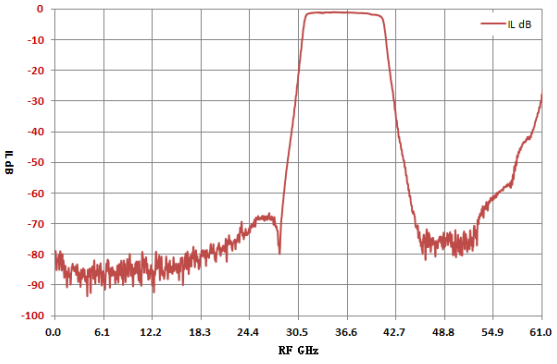
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



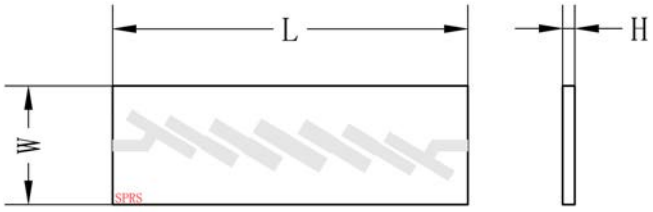
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	34.3	GHz
工作带宽	31.9-36.7	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-28.8GHz	dBc
带外抑制	40@40.0-45.0GHz	dBc

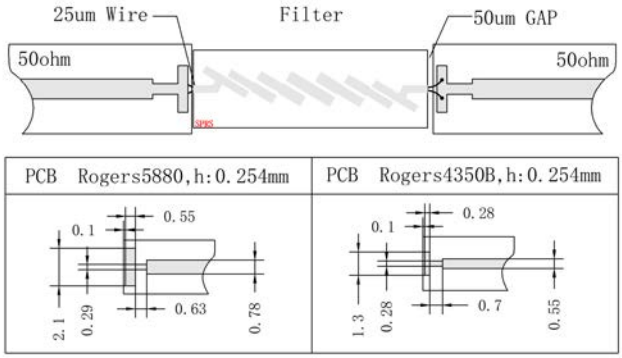
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



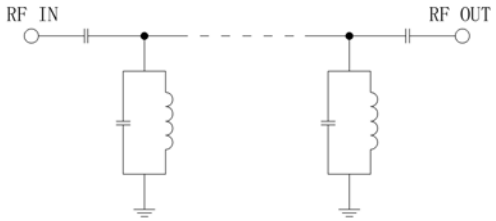
推荐装配图



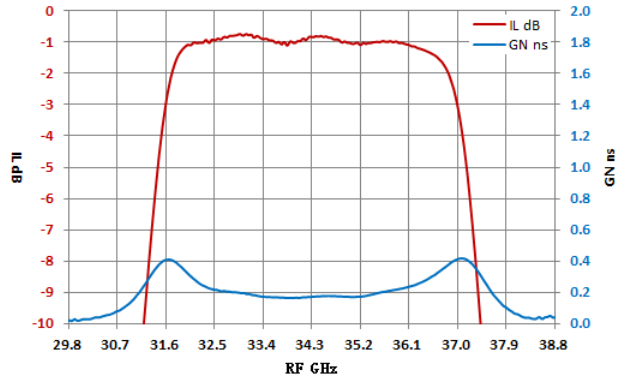
注意事项

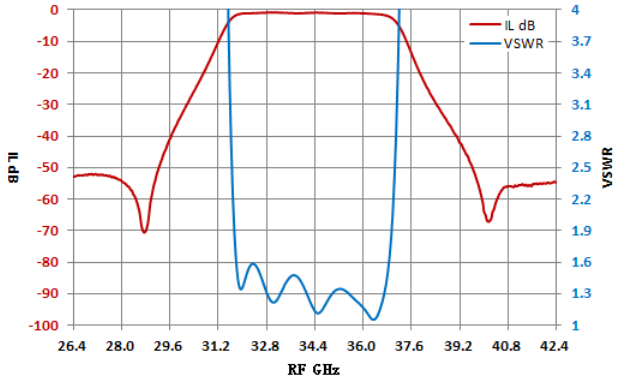
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.25mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

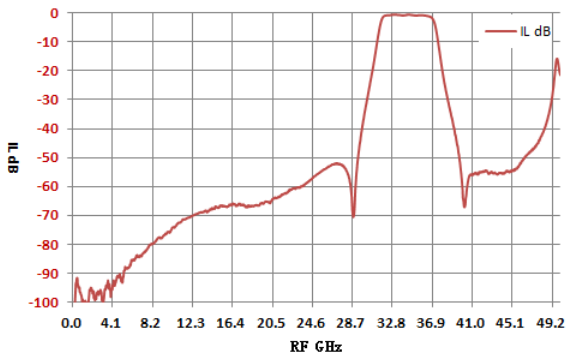
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

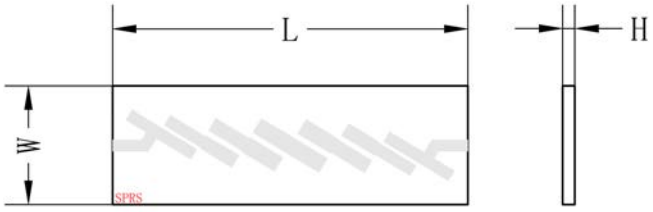
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	32.95	GHz
工作带宽	32.0-33.9	GHz
中心损耗	1.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-25.0GHz	dBc
带外抑制	40@37.0-44.0GHz	dBc

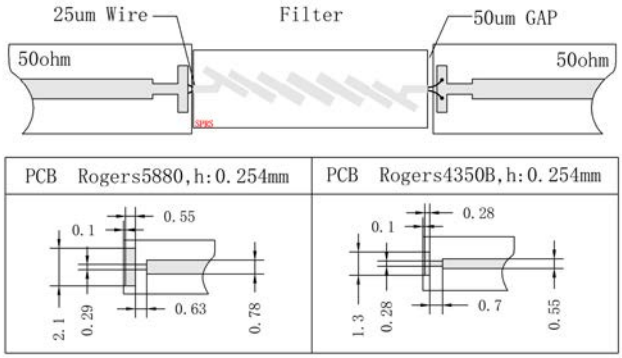
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



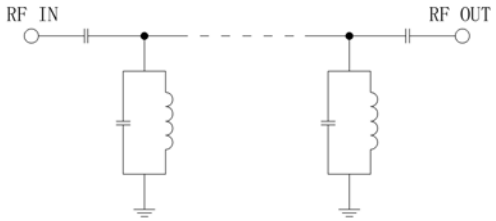
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

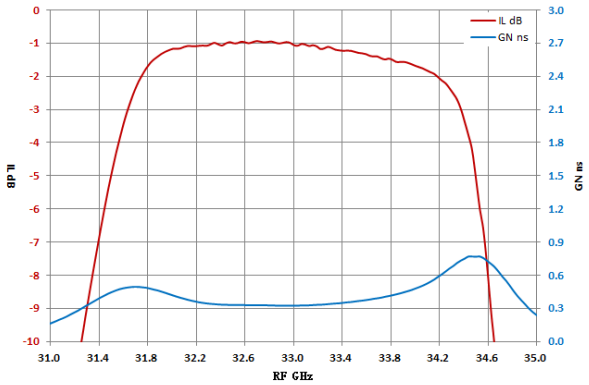
参考实物图

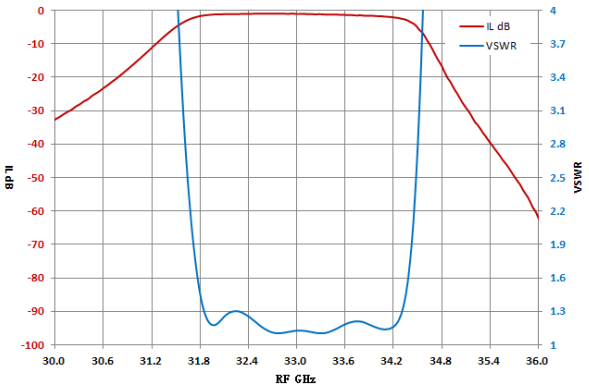


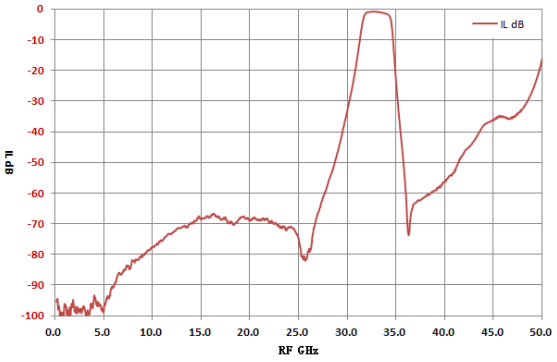
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



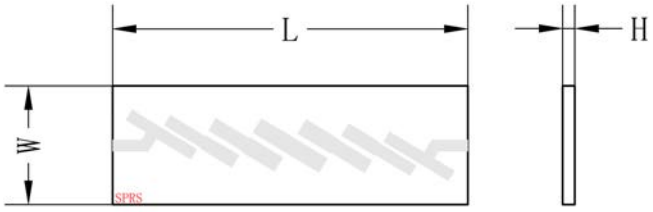
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	34.1	GHz
工作带宽	32.0-36.2	GHz
中心损耗	2.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-29.8GHz	dBc
带外抑制	40@38.2-48.0GHz	dBc

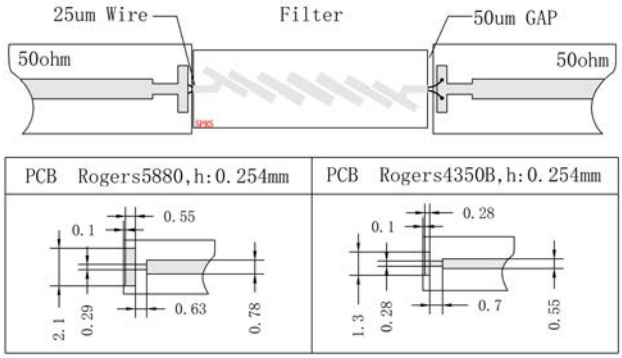
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



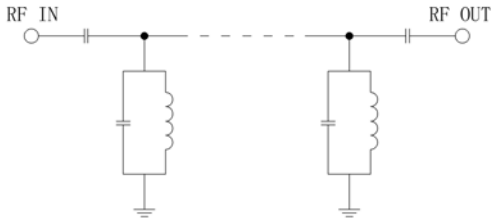
推荐装配图



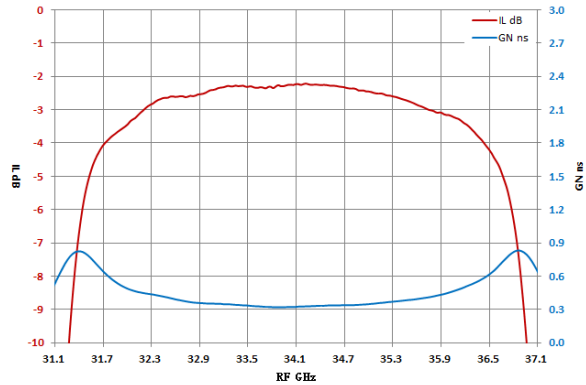
注意事项

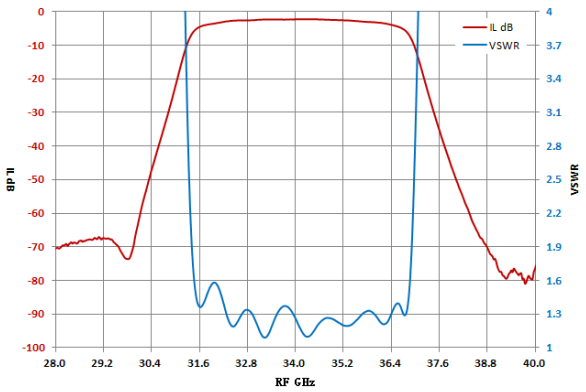
1： 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜,载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

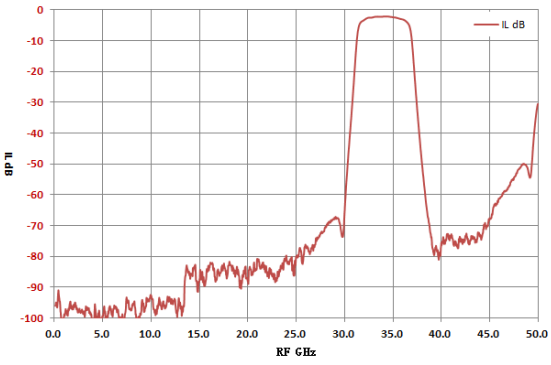
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



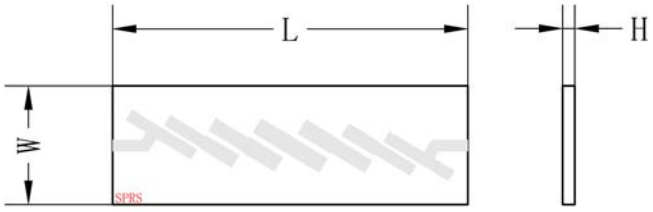
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	35.4	GHz
工作带宽	32.0-38.8	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-29.8GHz	dBc
带外抑制	40@41.8-50.0GHz	dBc

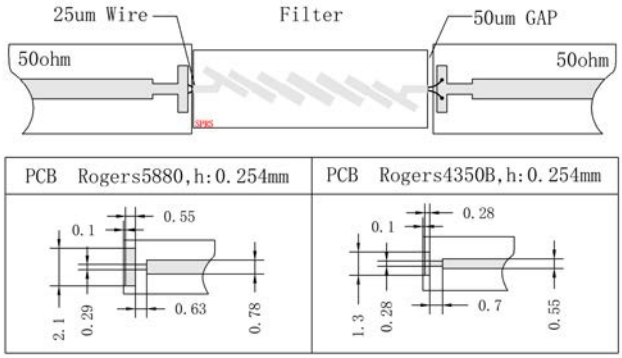
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



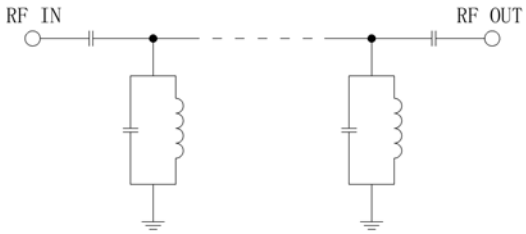
推荐装配图



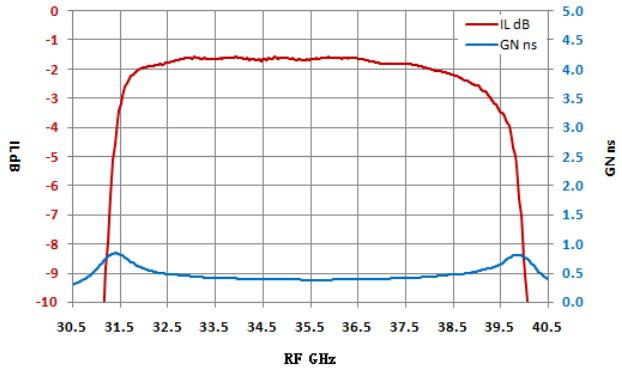
注意事项

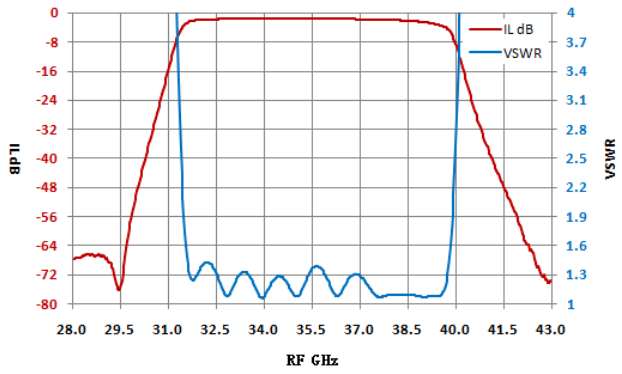
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

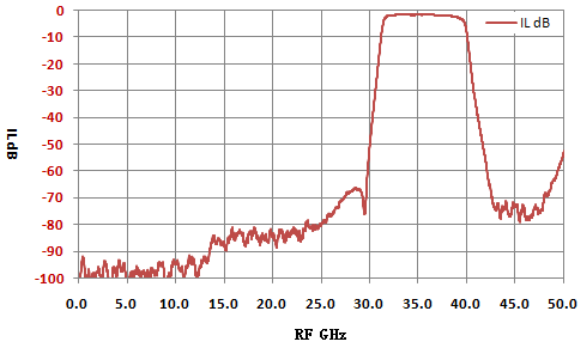
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



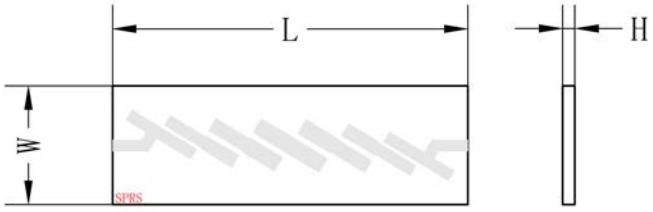
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	36.1	GHz
工作带宽	32.0-40.2	GHz
中心损耗	1.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-26.2GHz	dBc
带外抑制	40@46.9-53.0GHz	dBc

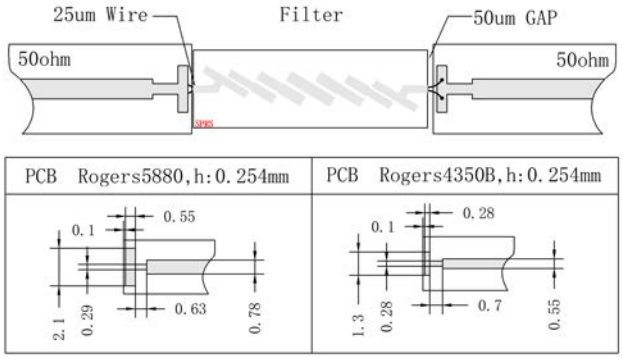
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：1.9，h：0.26

外形图：端口居中



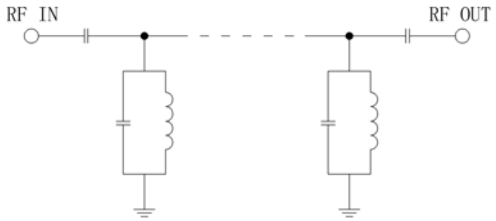
推荐装配图



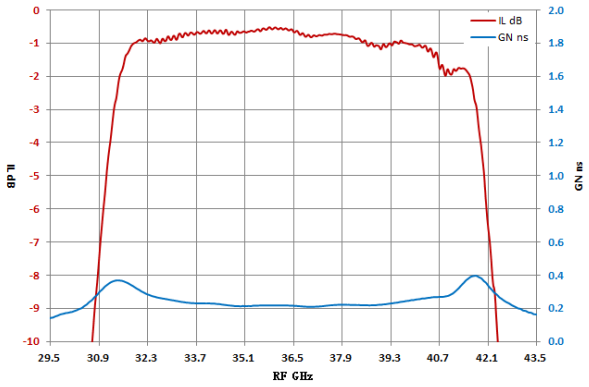
注意事项

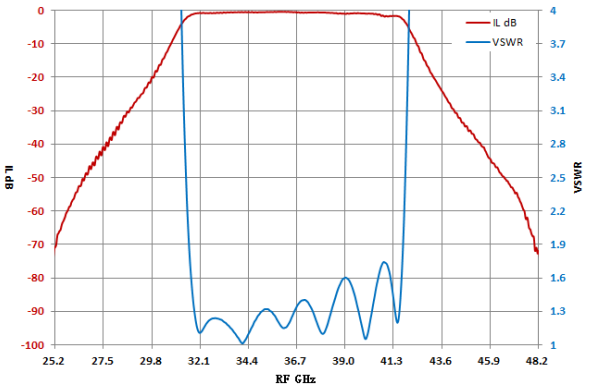
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

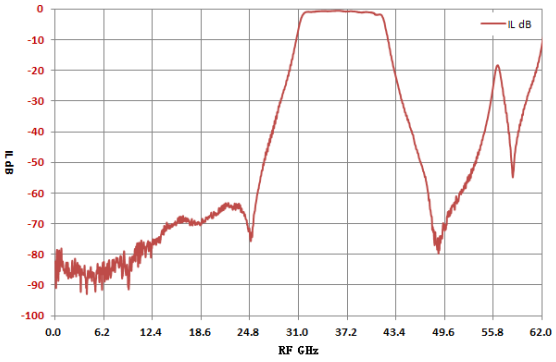
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



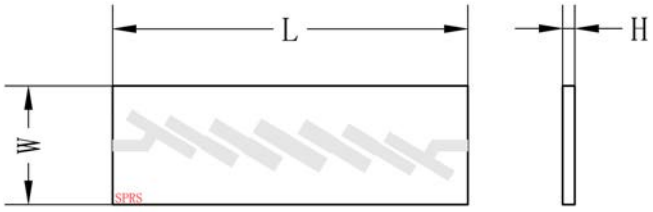
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	36.1	GHz
工作带宽	32.0-40.2	GHz
中心损耗	1.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-29.8GHz	dBc
带外抑制	40@43.5-47.0GHz	dBc

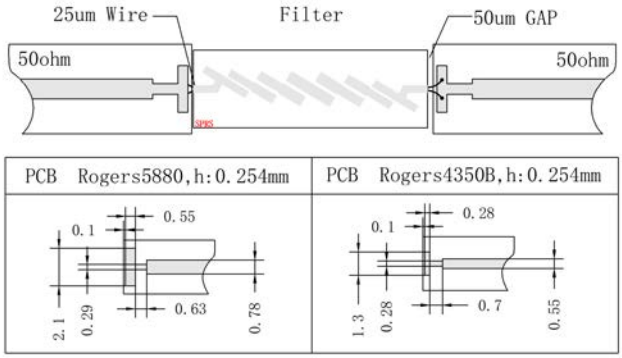
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



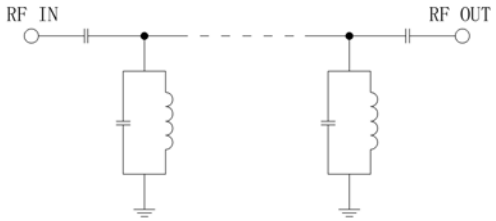
推荐装配图



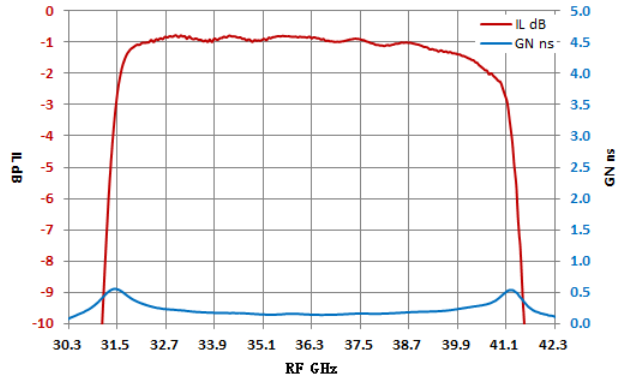
注意事项

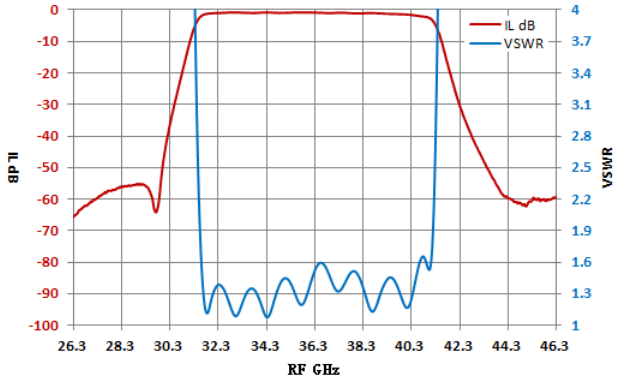
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

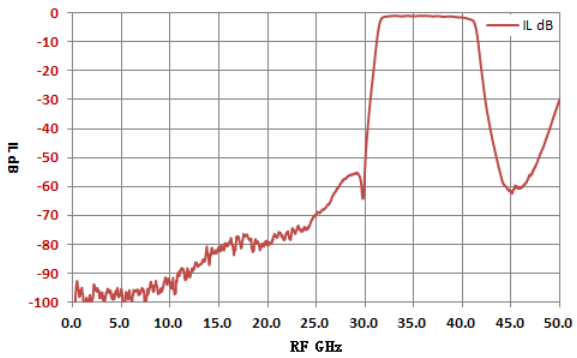
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

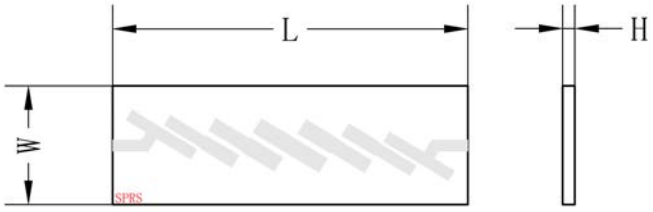
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	36.3	GHz
工作带宽	32.0-40.6	GHz
中心损耗	2.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-27.5GHz	dBc
带外抑制	40@46.1-50.0GHz	dBc

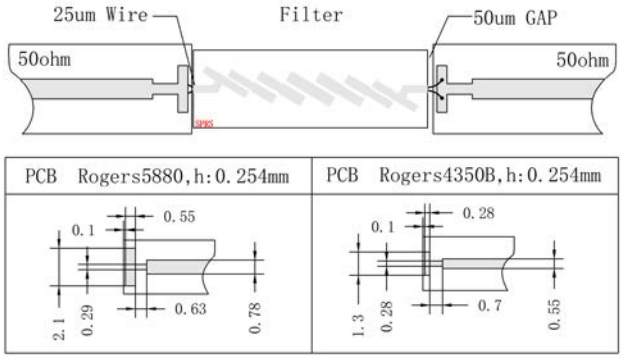
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



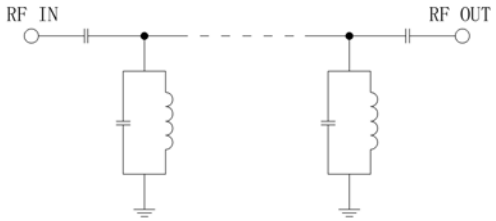
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.87mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

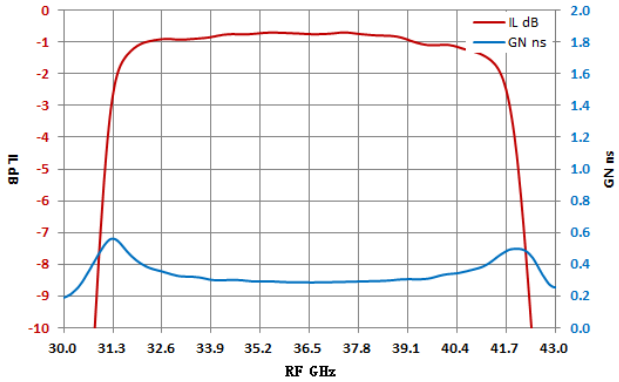
参考实物图

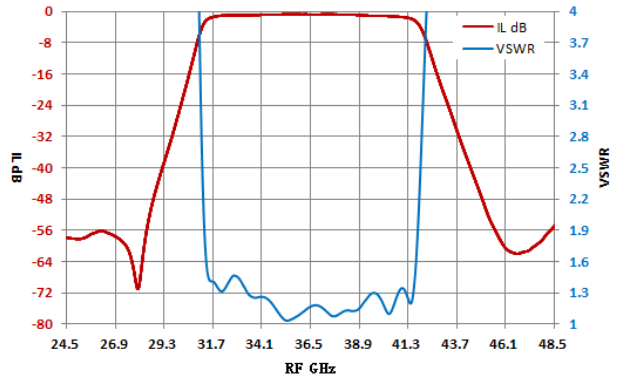


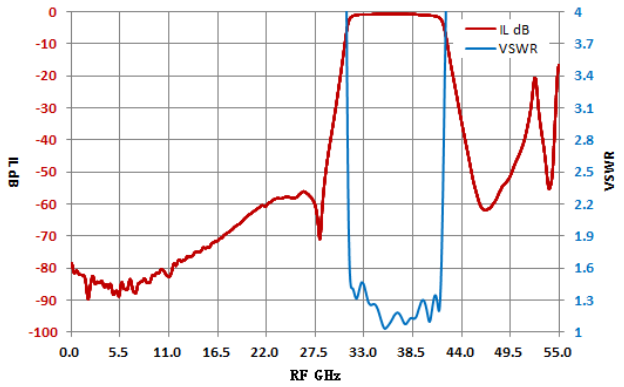
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

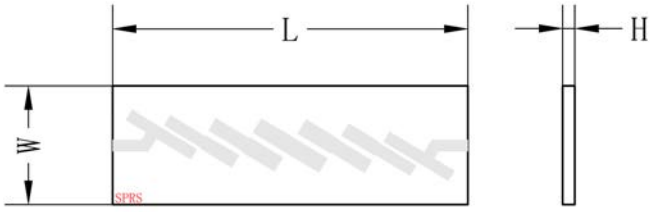
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	40.0	GHz
工作带宽	32.0-48.0	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-26.0GHz	dBc
带外抑制	40@57.0-60.0GHz	dBc

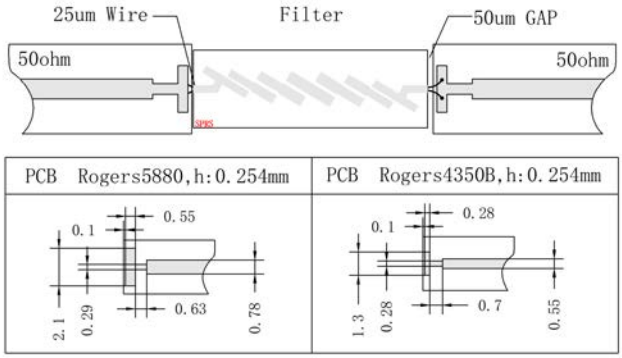
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：1.8，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



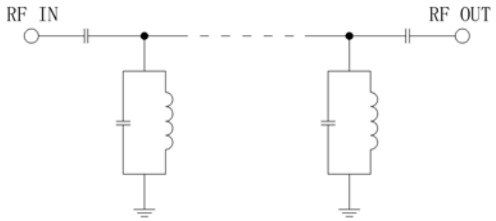
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

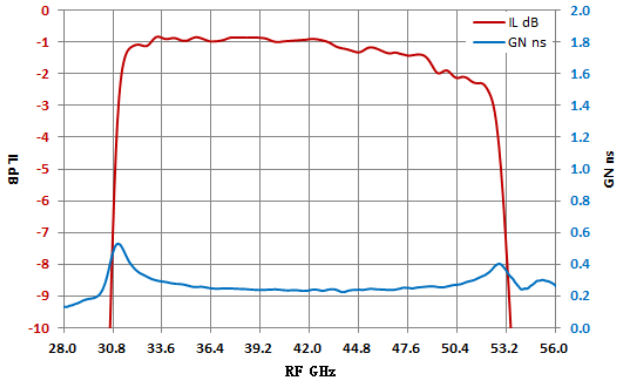
参考实物图

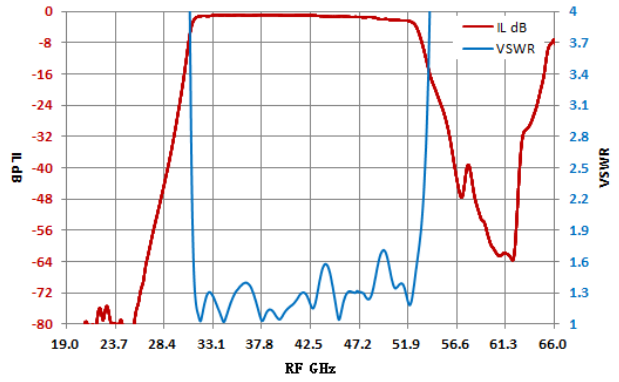


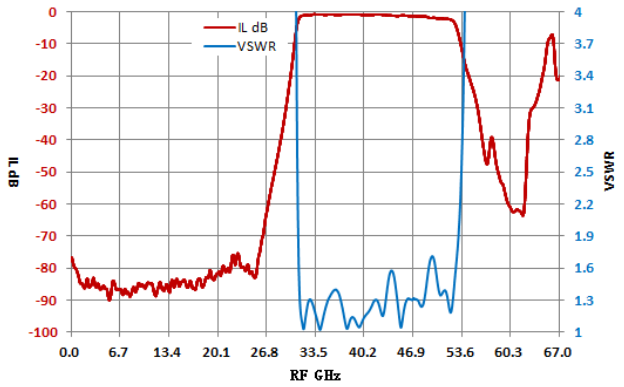
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



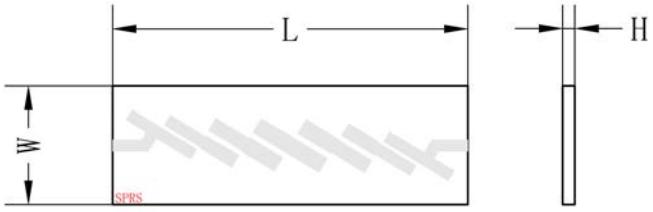
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	34.9	GHz
工作带宽	32.2-37.6	GHz
中心损耗	1.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-29.8GHz	dBc
带外抑制	40@40.0-46.0GHz	dBc

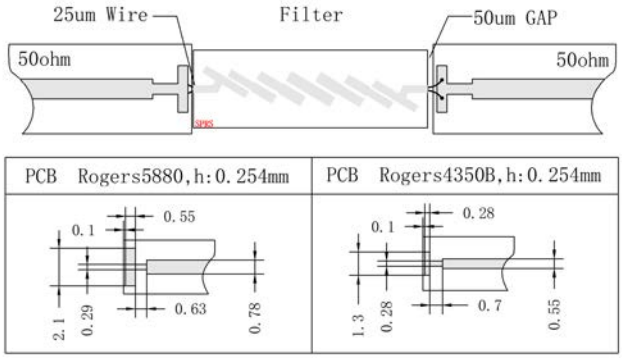
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



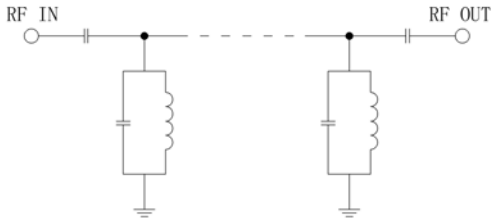
推荐装配图



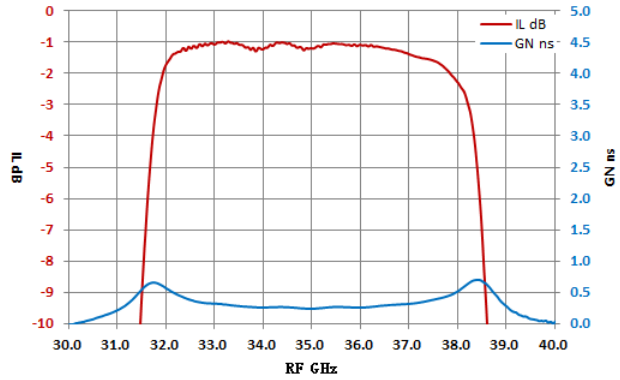
注意事项

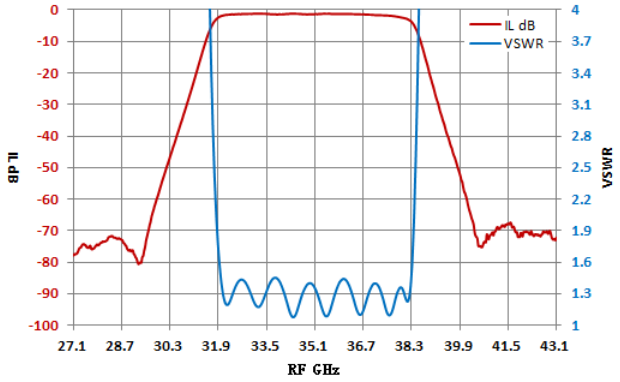
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

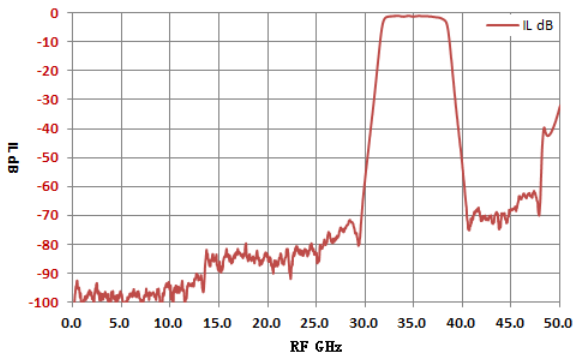
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

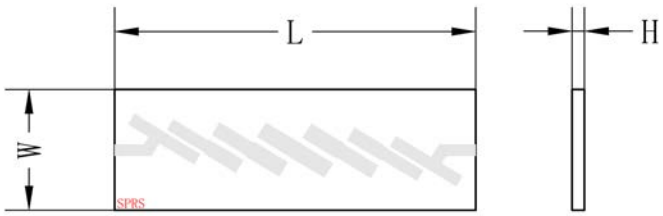
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	33.0	GHz
工作带宽	32.6-33.4	GHz
中心损耗	3.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-31.0GHz	dBc
带外抑制	40@35.0-41.0GHz	dBc

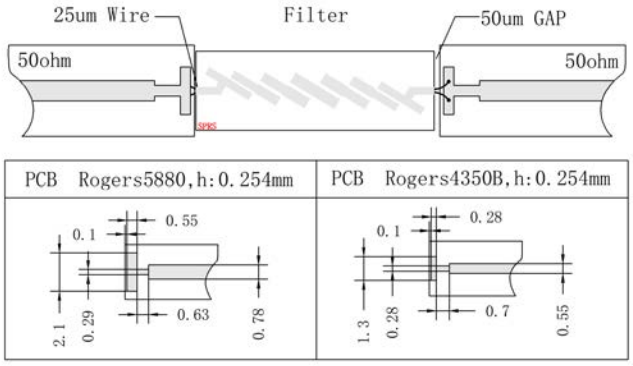
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：6.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

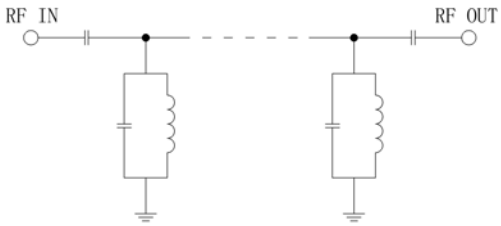
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

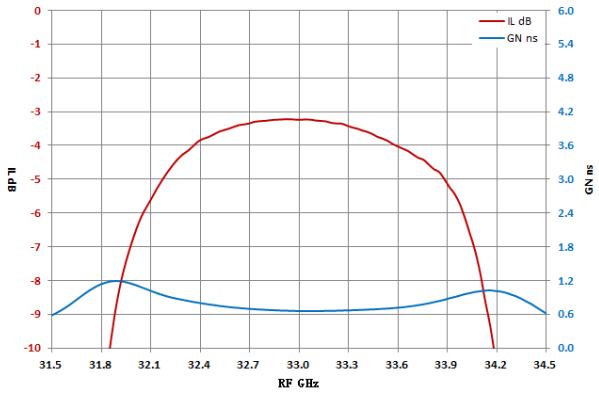
参考图

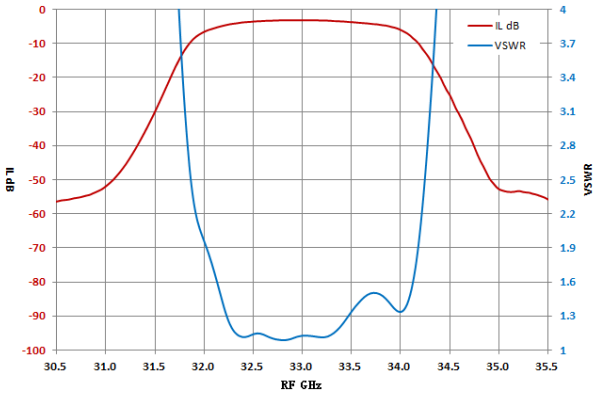


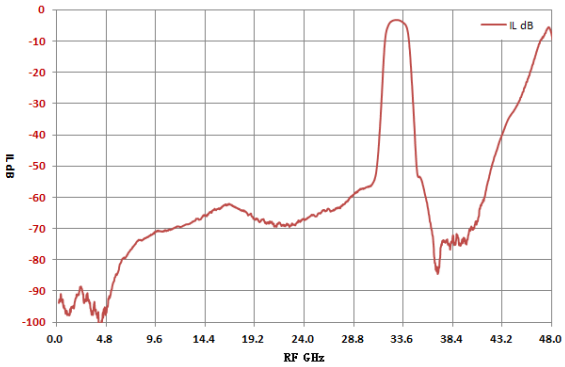
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

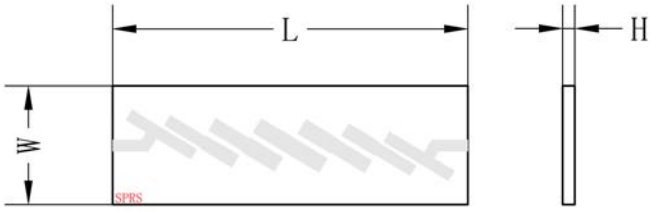
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	34.9	GHz
工作带宽	32.7-37.1	GHz
中心损耗	1.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-30.0GHz	dBc
带外抑制	40@40.2-45.0GHz	dBc

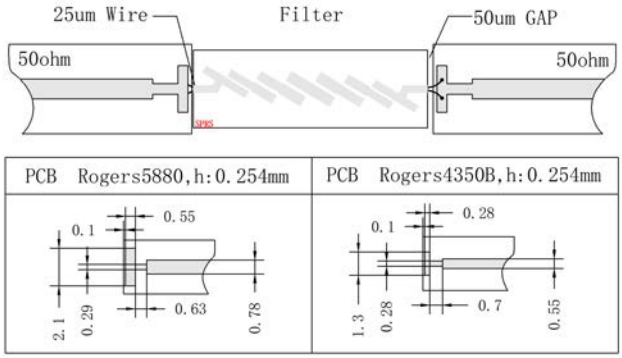
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



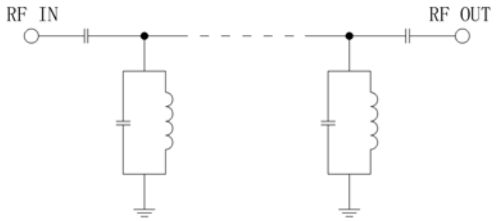
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

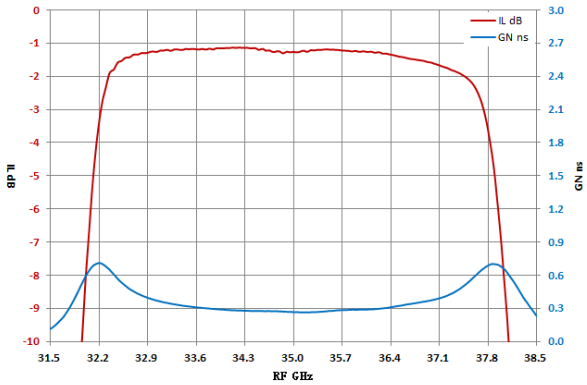
参考实物图

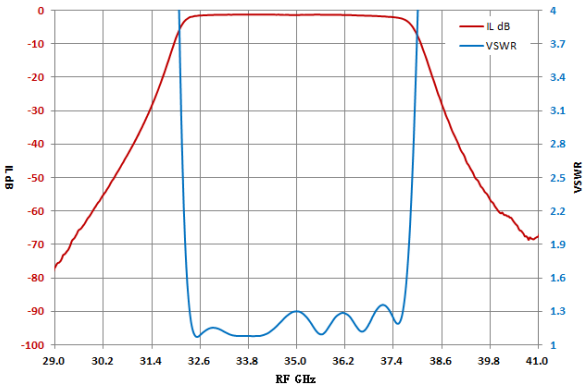


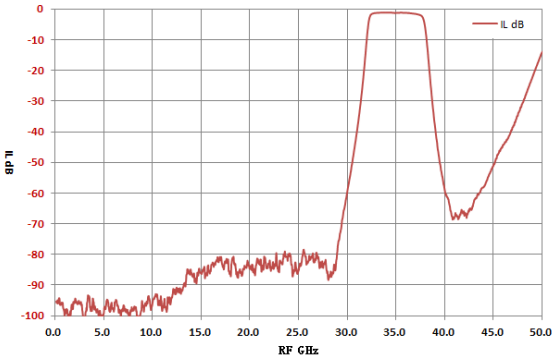
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



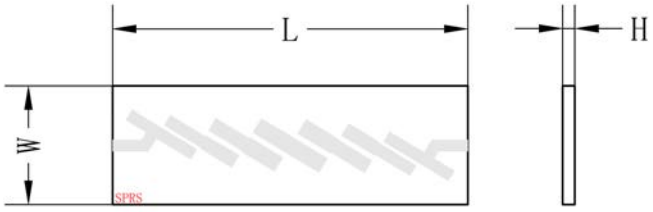
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	35.3	GHz
工作带宽	32.8-37.8	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-29.0GHz	dBc
带外抑制	40@41.5-54.0GHz	dBc

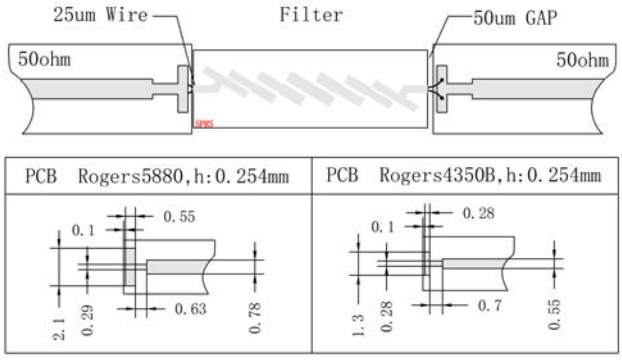
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



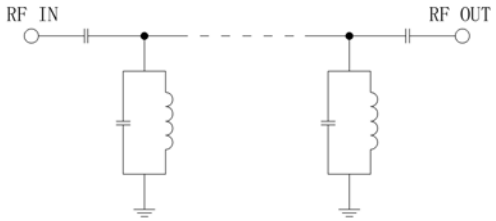
推荐装配图



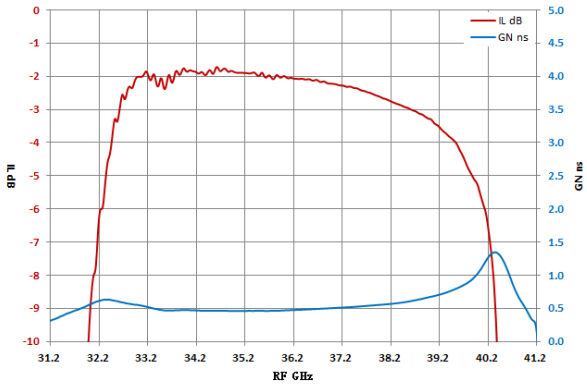
注意事项

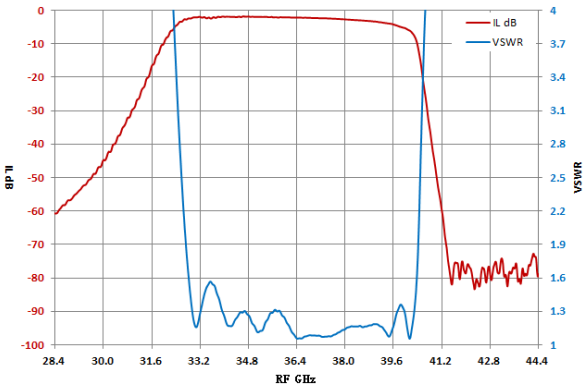
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

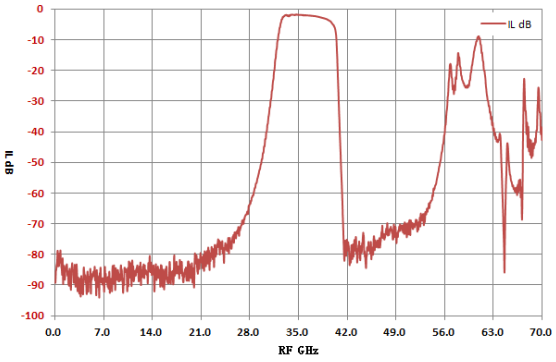
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

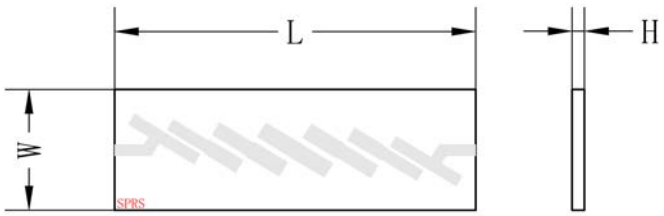
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	33.8	GHz
工作带宽	33.0-34.6	GHz
中心损耗	3.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-30.8GHz	dBc
带外抑制	40@37.0-45.0GHz	dBc

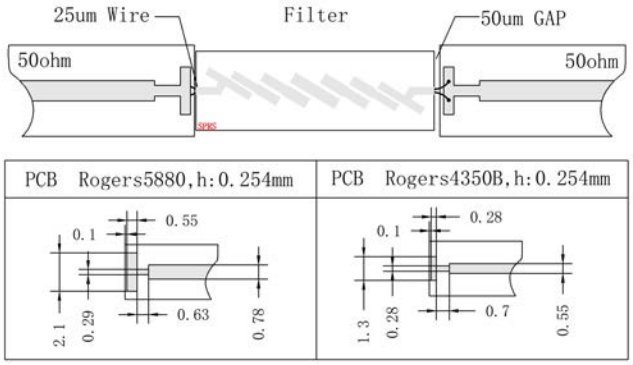
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：6.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

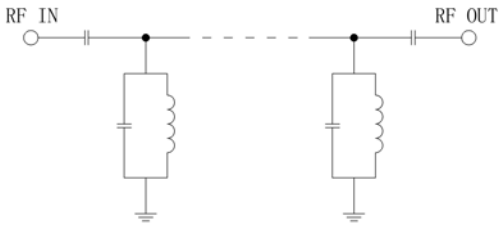
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

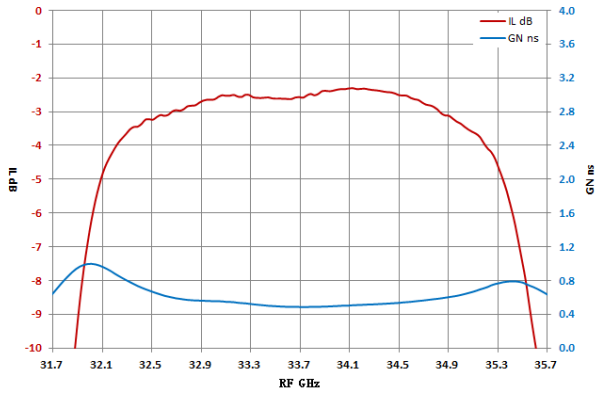
参考图

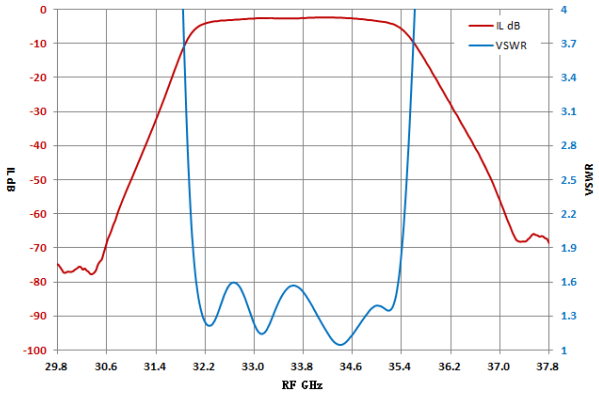


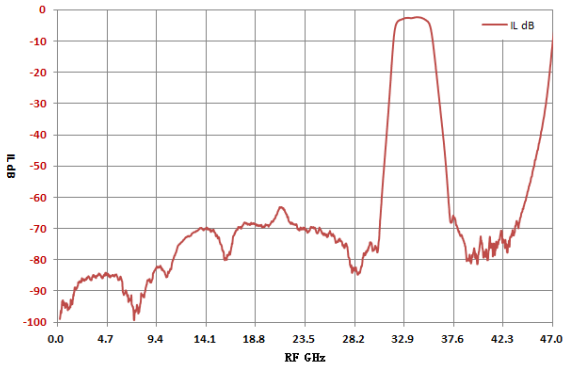
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



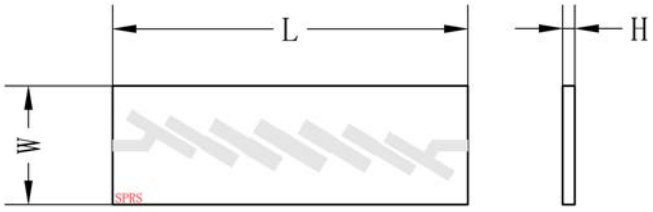
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	34.4	GHz
工作带宽	33.0-35.8	GHz
中心损耗	2.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-31.0GHz	dBc
带外抑制	40@38.0-45.0GHz	dBc

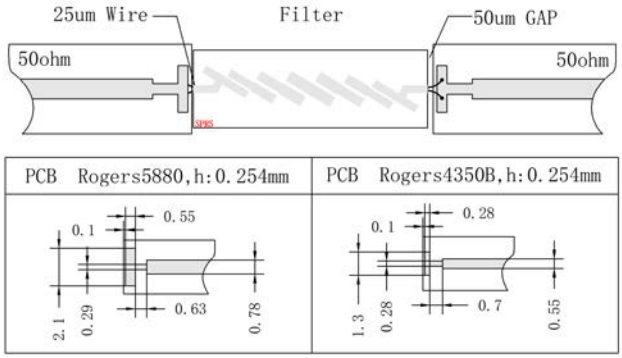
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



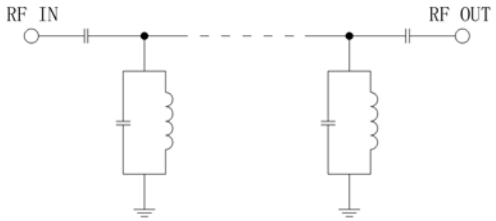
推荐装配图



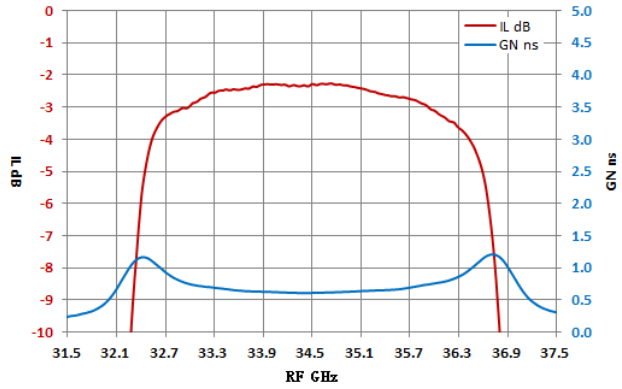
注意事项

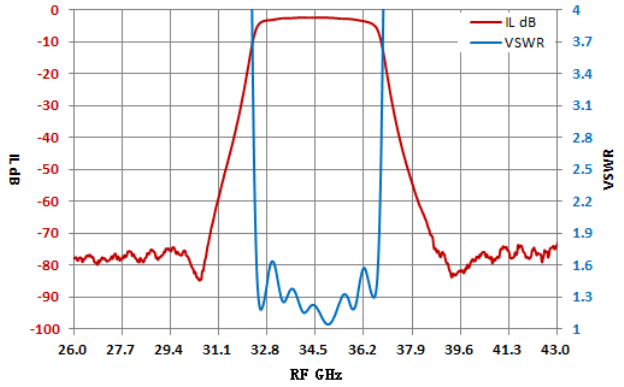
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

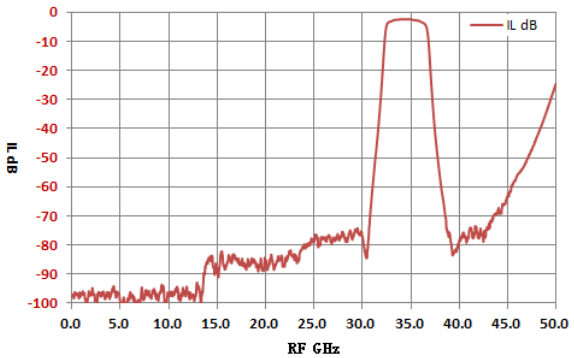
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



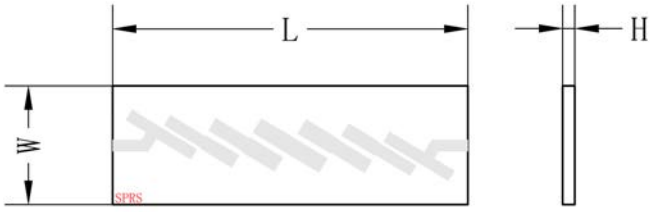
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	34.8	GHz
工作带宽	33.0-36.6	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-31.2GHz	dBc
带外抑制	40@38.8-48.0GHz	dBc

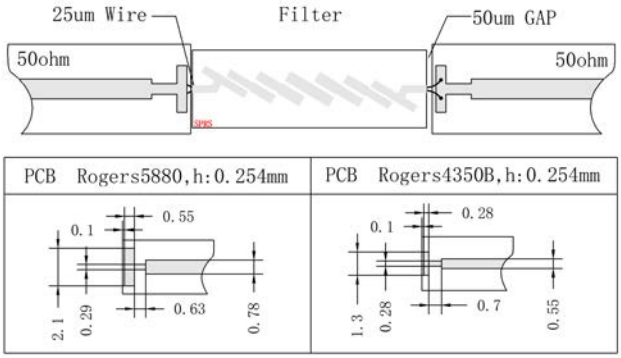
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



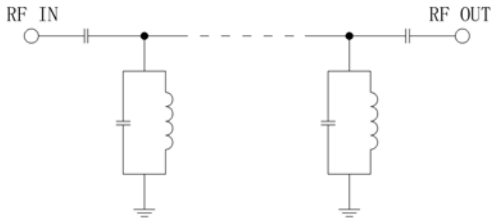
推荐装配图



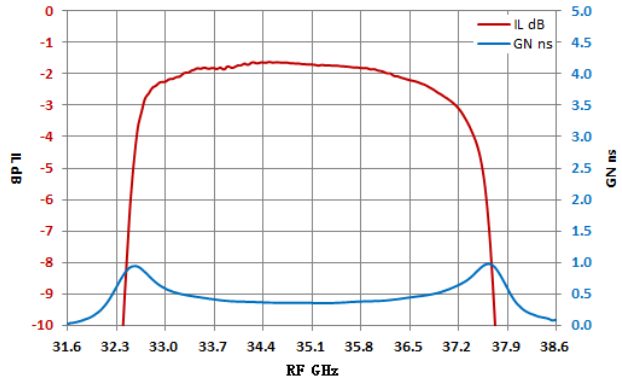
注意事项

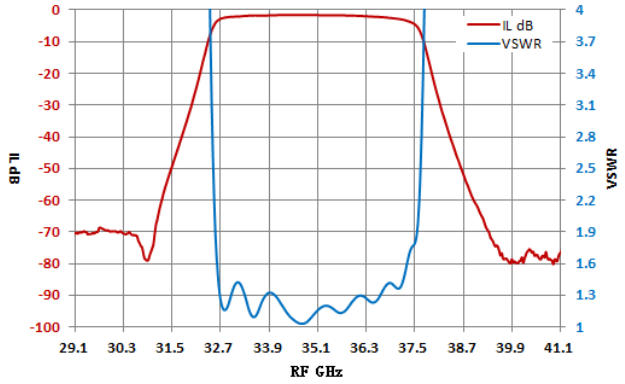
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.25mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

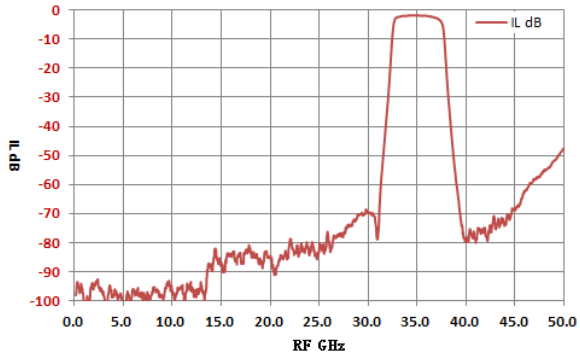
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

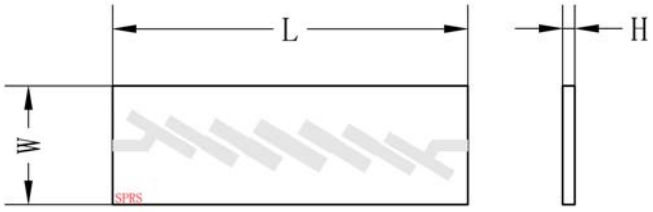
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	35.3	GHz
工作带宽	33.0-37.6	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-30.2GHz	dBc
带外抑制	40@41.9-47.0GHz	dBc

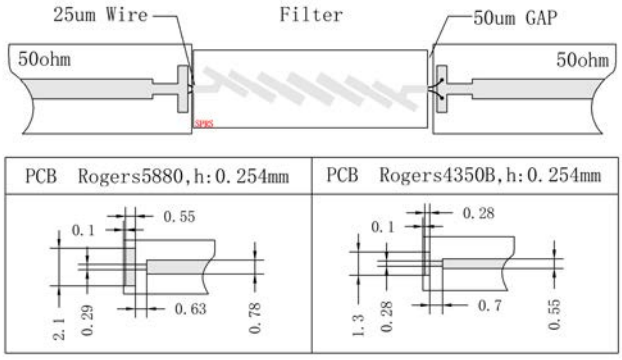
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



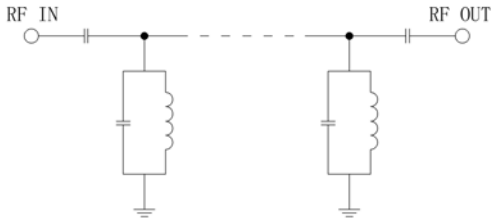
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

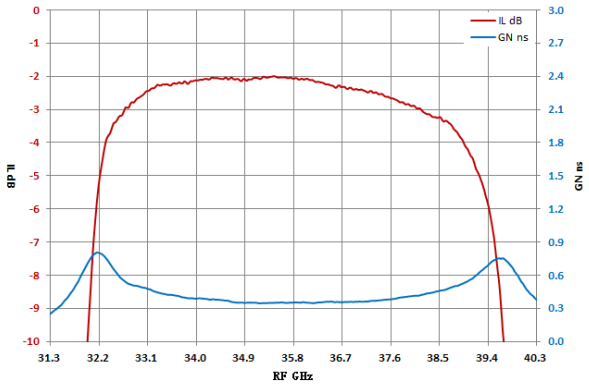
参考实物图

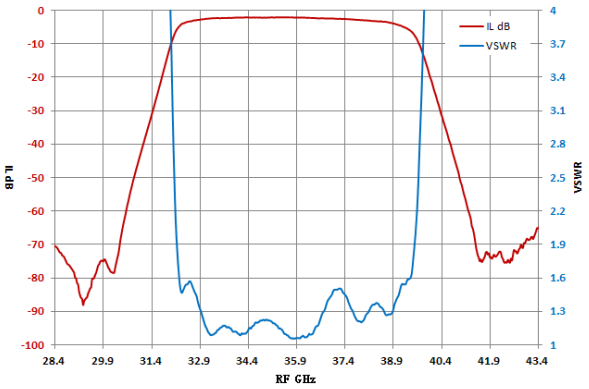


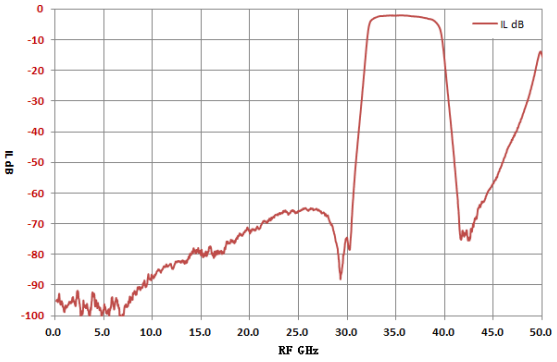
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

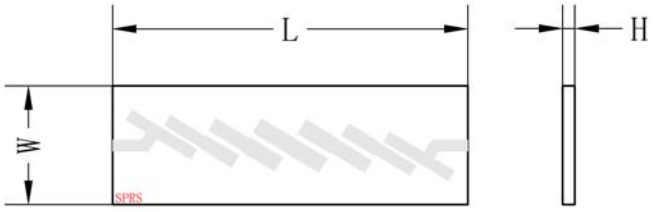
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	35.6	GHz
工作带宽	33.0-38.2	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-29.6GHz	dBc
带外抑制	40@41.7-53.0GHz	dBc

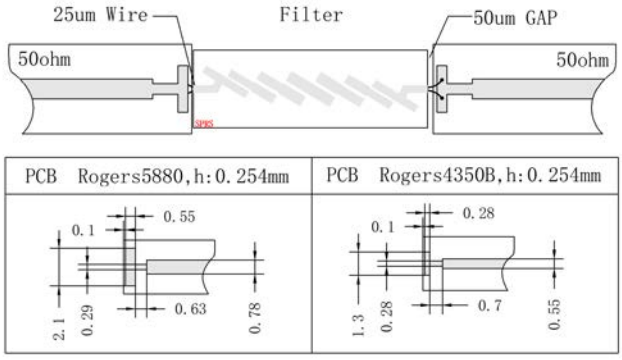
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



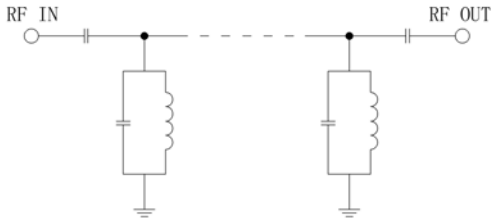
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

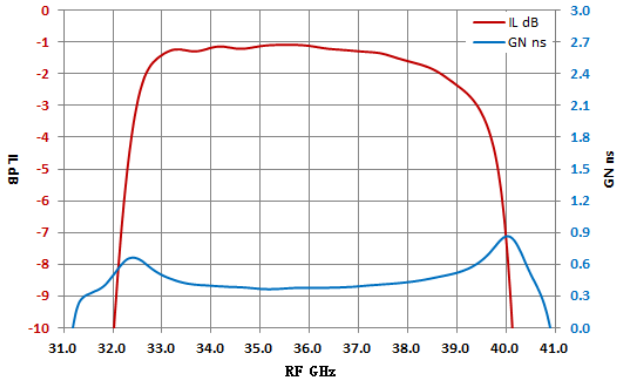
参考实物图

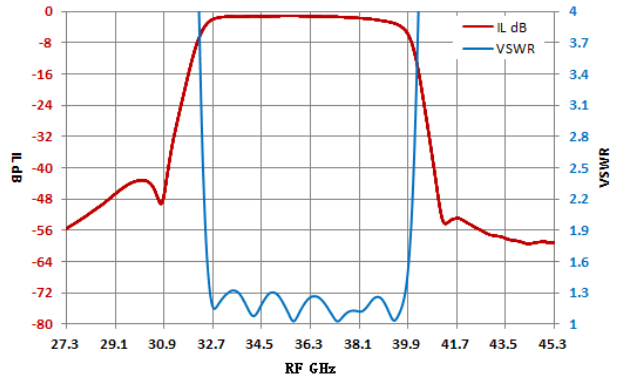


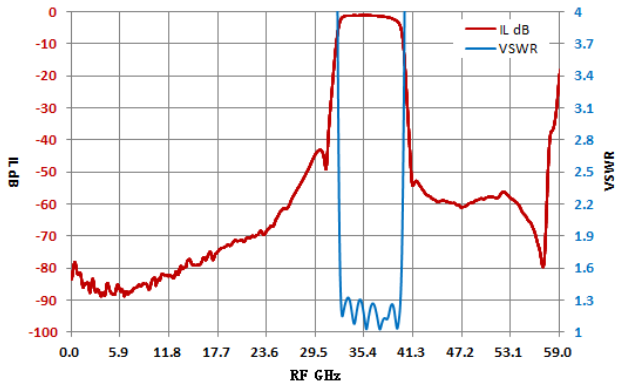
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

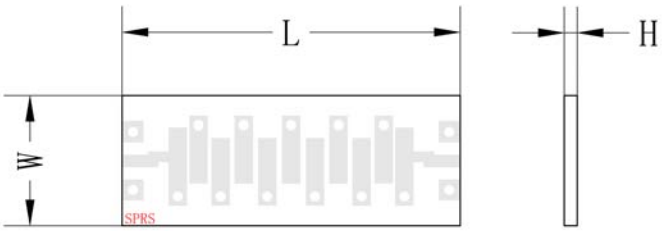
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	36.0	GHz
工作带宽	33.0-39.0	GHz
中心损耗	2.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-30.2GHz	dBc
带外抑制	40@42.2-63.0GHz	dBc

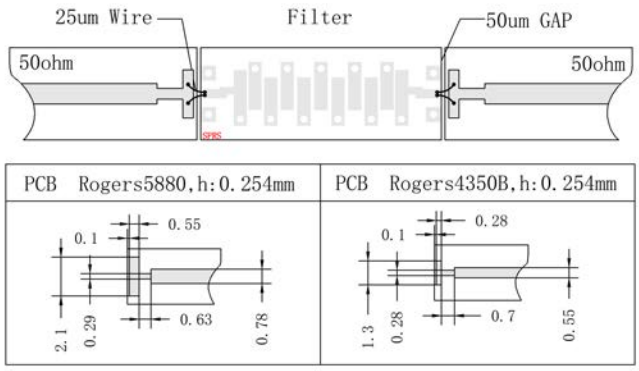
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

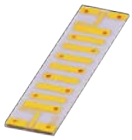
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

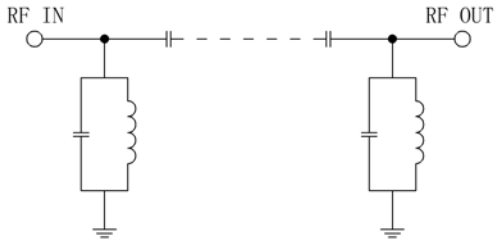
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

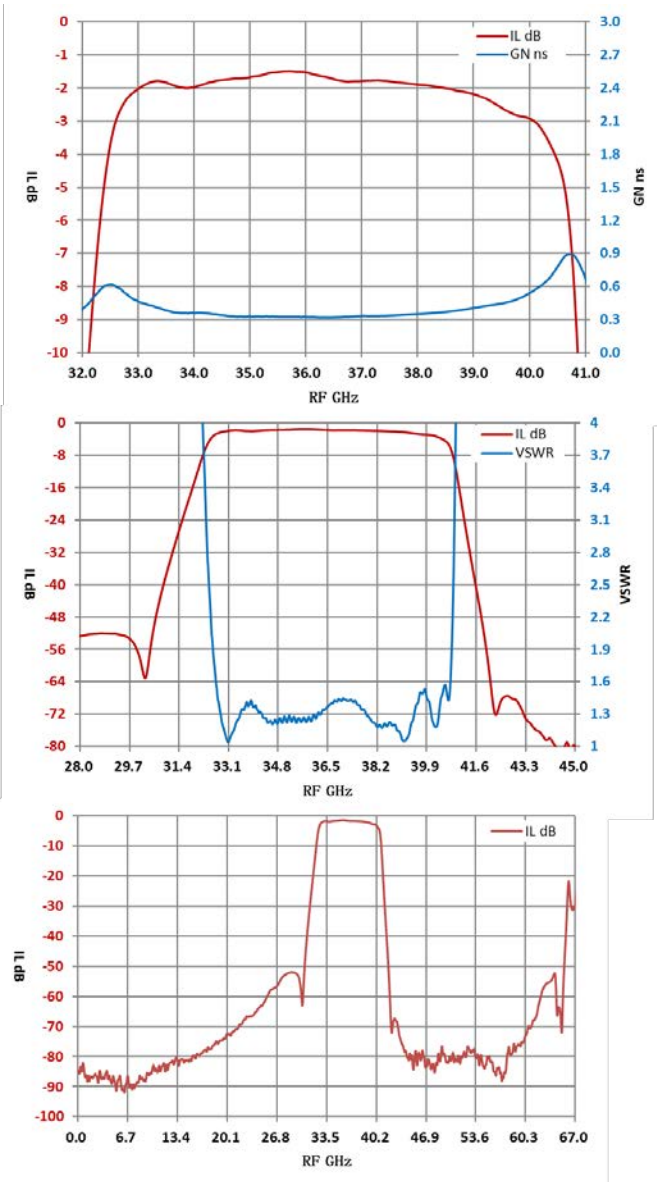
参考图



原理图



典型曲线



产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



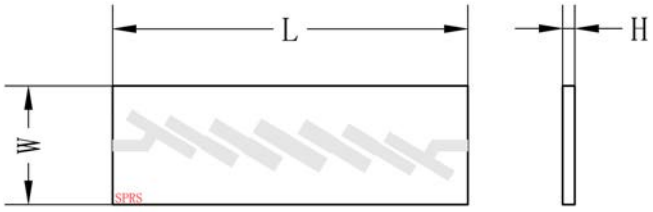
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	36.0	GHz
工作带宽	33.0-39.0	GHz
中心损耗	1.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-30.2GHz	dBc
带外抑制	40@42.4-48.0GHz	dBc

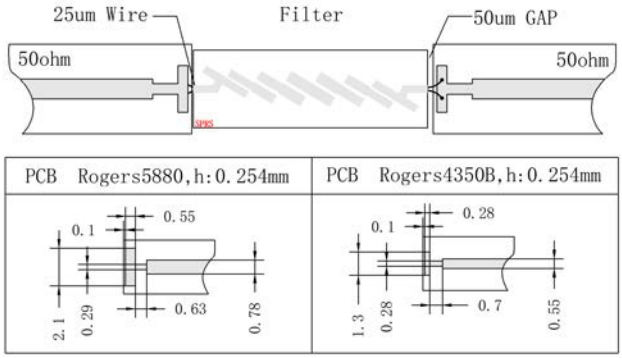
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



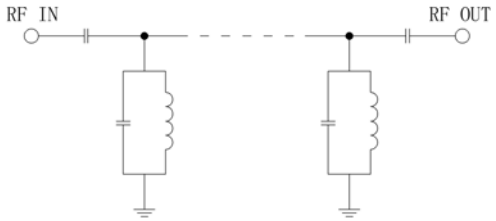
推荐装配图



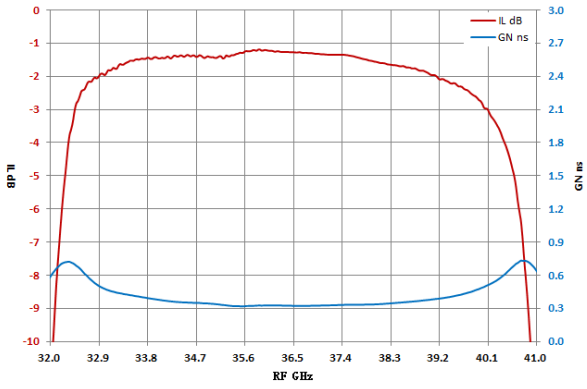
注意事项

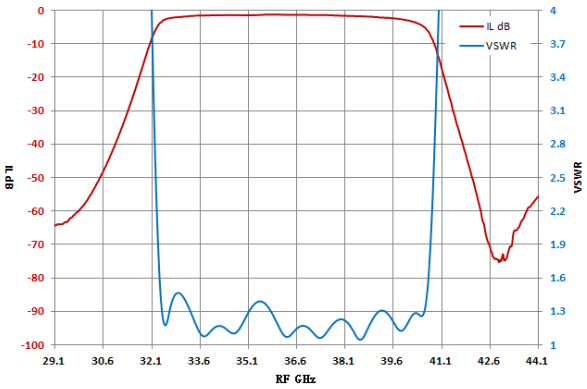
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

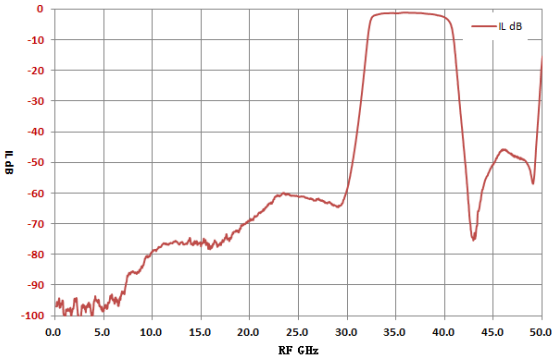
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

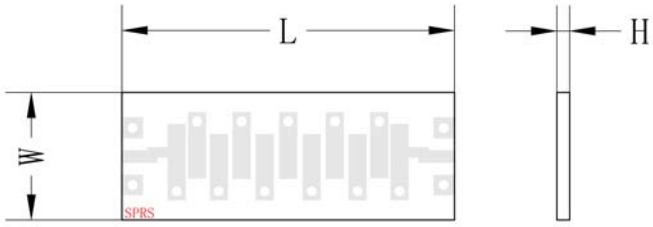
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	36.0	GHz
工作带宽	33.0-39.0	GHz
中心损耗	2.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-30.0GHz	dBc
带外抑制	40@41.8-55.0GHz	dBc

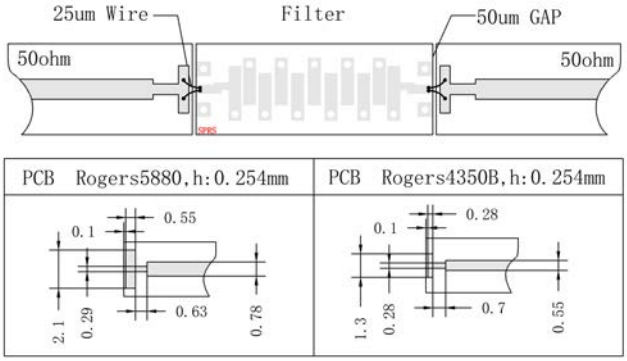
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



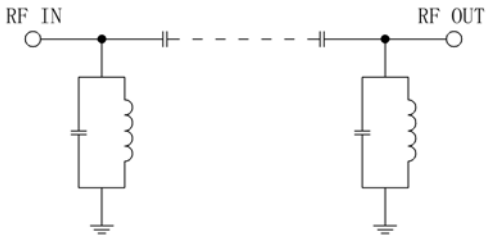
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

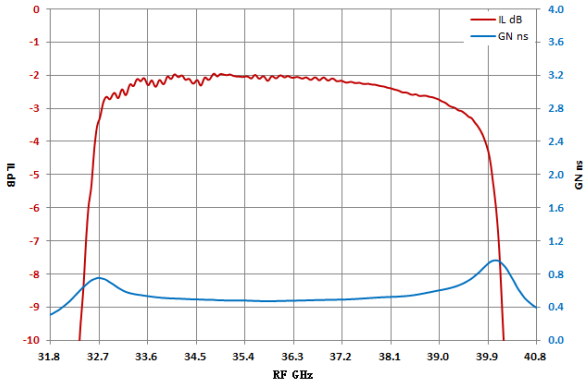
参考实物图

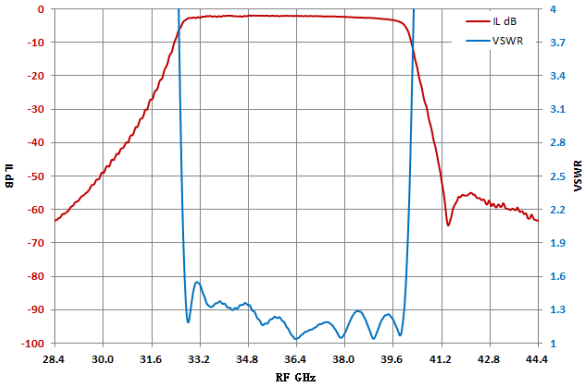


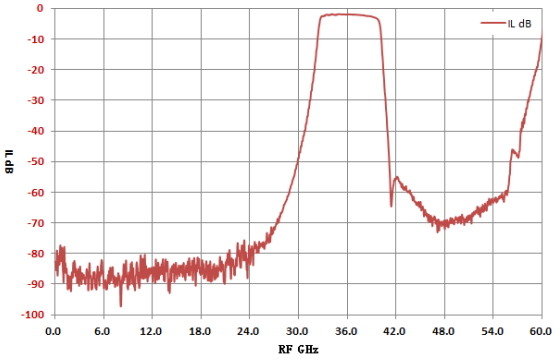
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



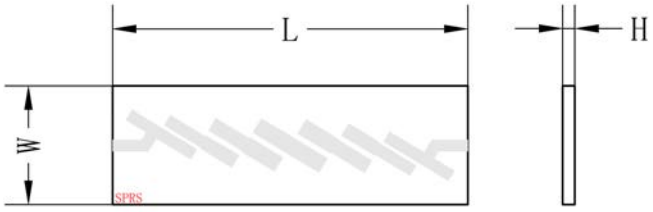
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	37.2	GHz
工作带宽	33.0-41.4	GHz
中心损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-29.0GHz	dBc
带外抑制	40@46.0-59.0GHz	dBc

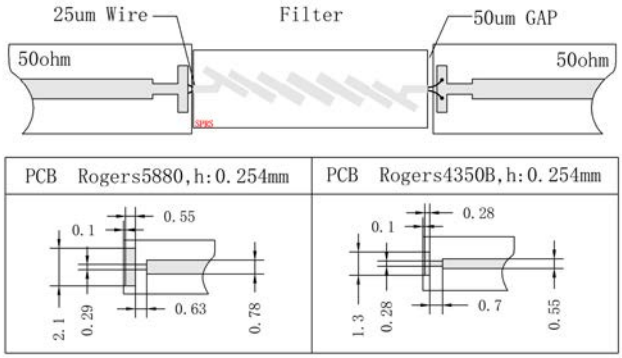
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：1.8，h：0.26

外形图：端口居中



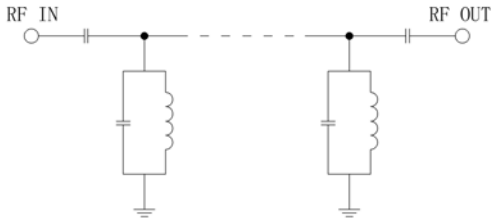
推荐装配图



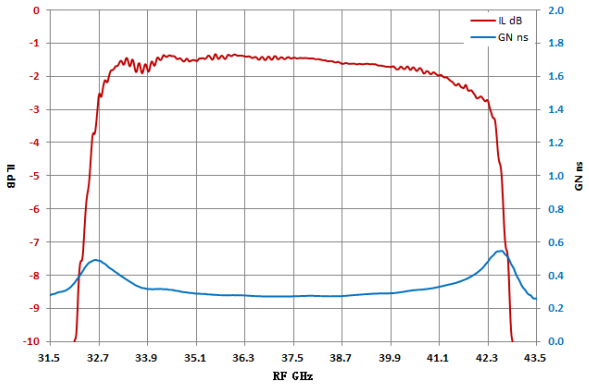
注意事项

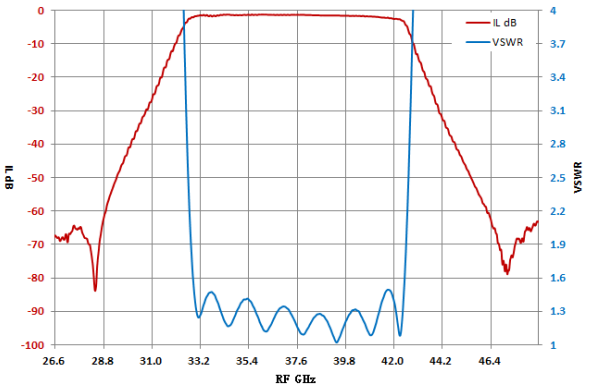
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

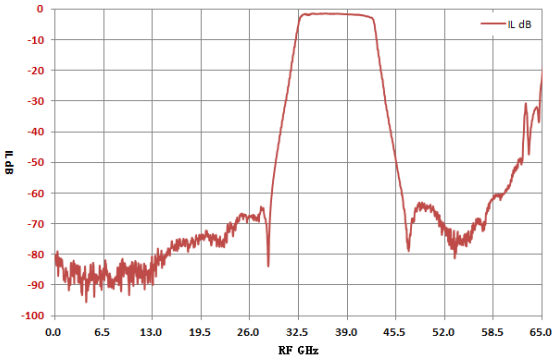
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

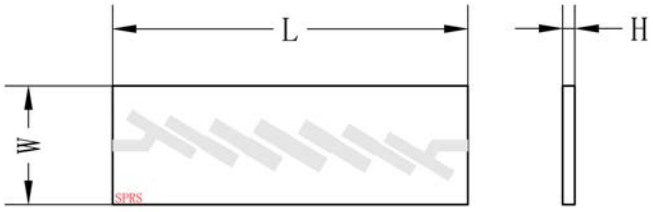
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	35.5	GHz
工作带宽	33.2-37.8	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-30.5GHz	dBc
带外抑制	40@41.7-48.0GHz	dBc

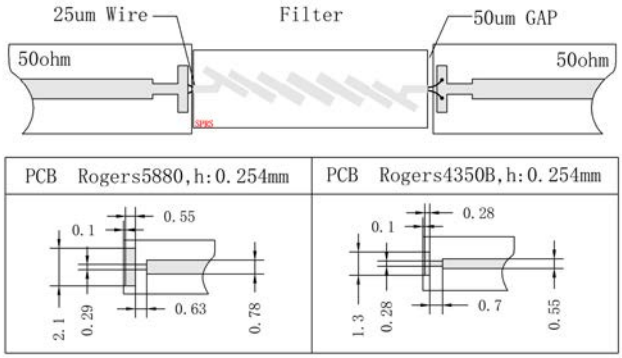
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



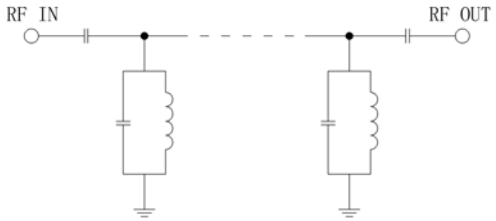
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

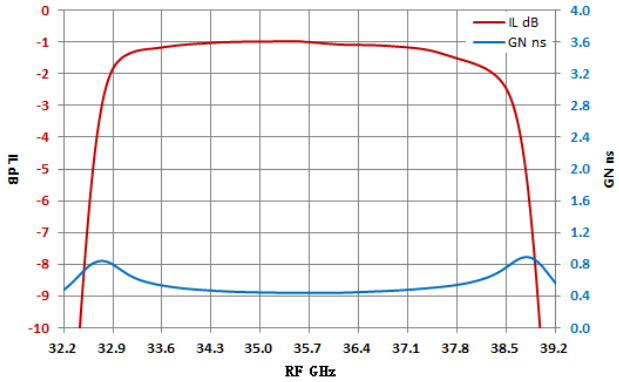
参考实物图

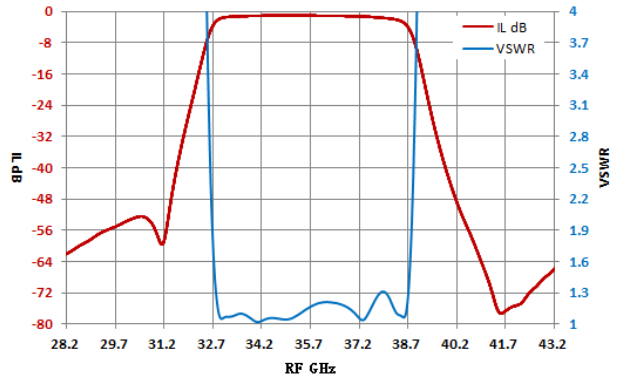


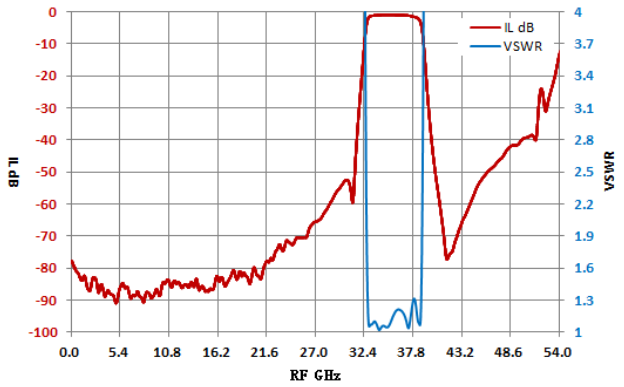
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

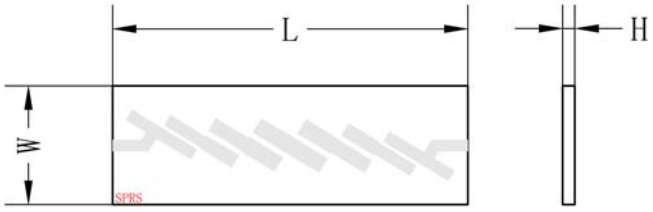
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	35.85	GHz
工作带宽	33.2-38.5	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-31.1GHz	dBc
带外抑制	40@41.6-50.0GHz	dBc

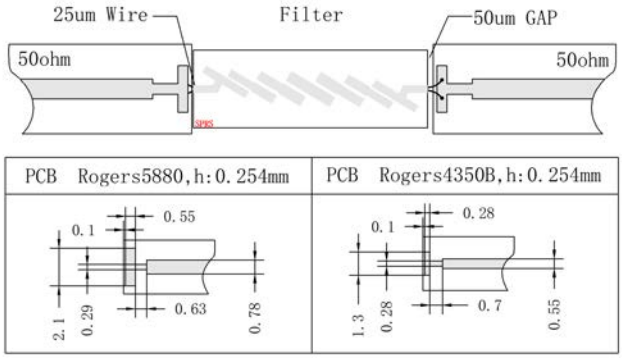
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：10.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



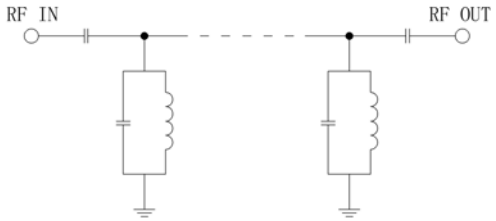
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

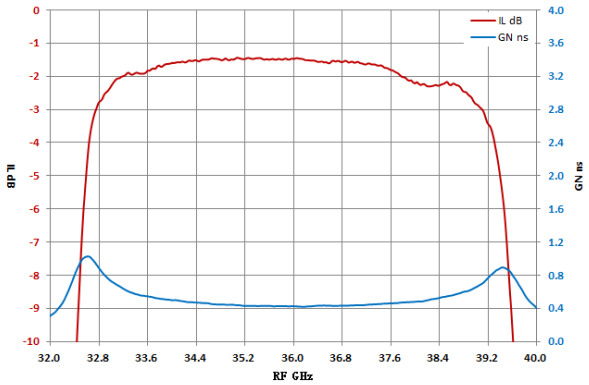
参考实物图

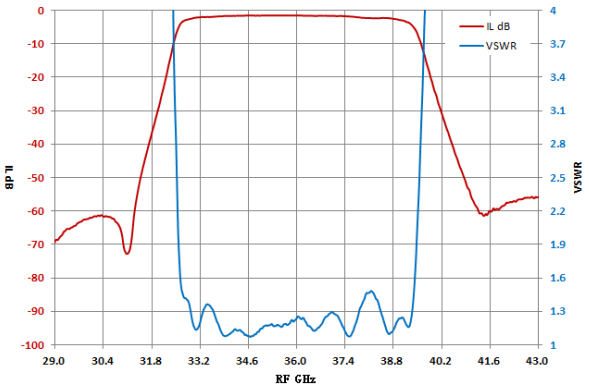


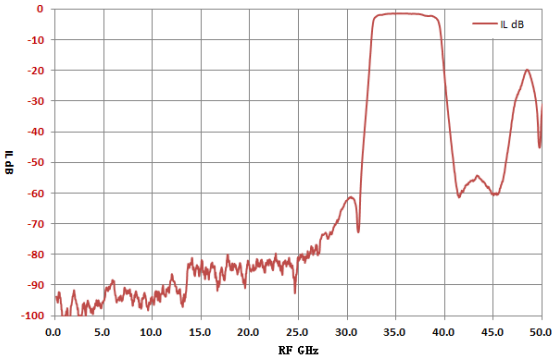
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



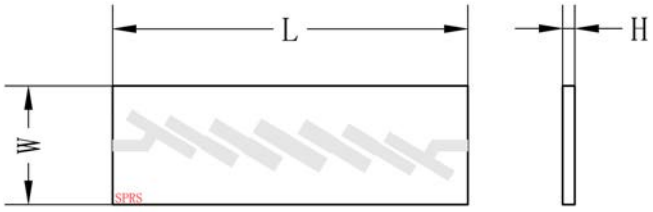
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	36.3	GHz
工作带宽	33.2-39.4	GHz
中心损耗	1.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-31.0GHz	dBc
带外抑制	40@42.8-50.0GHz	dBc

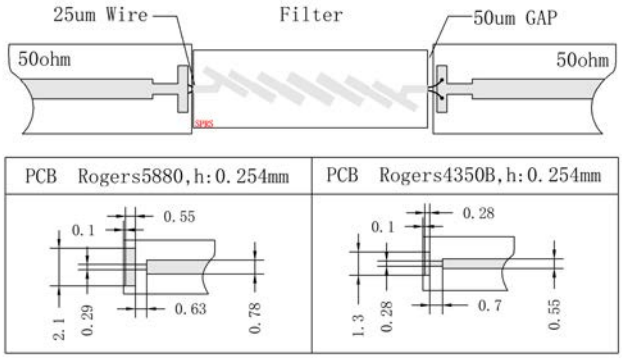
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



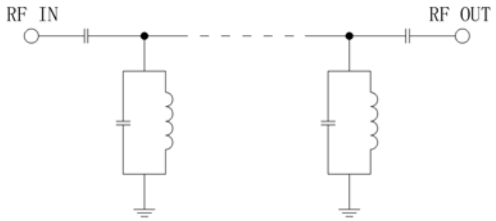
推荐装配图



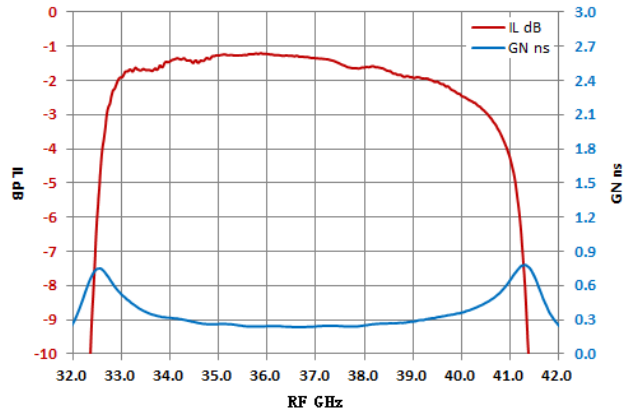
注意事项

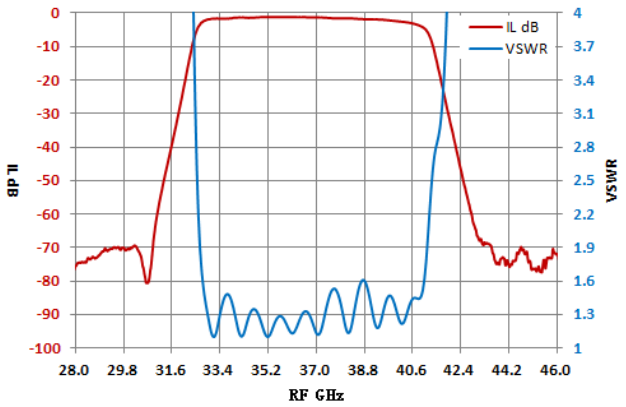
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.25mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

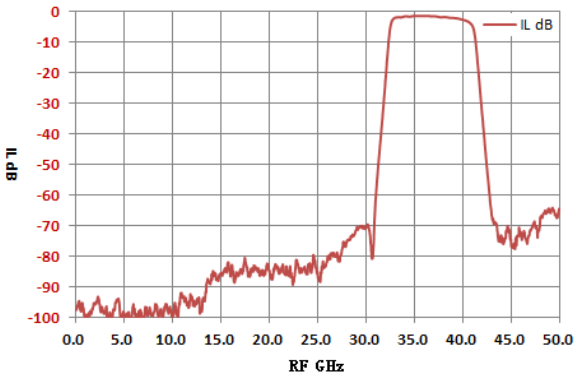
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

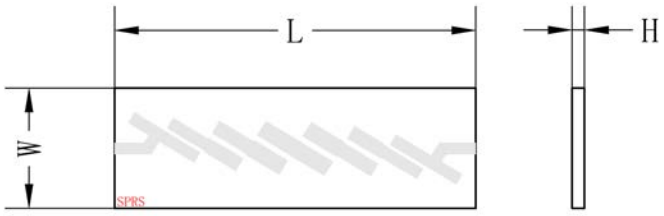
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	36.8	GHz
工作带宽	33.2-39.8	GHz
中心损耗	2.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-30.5GHz	dBc
带外抑制	40@44.1-54.0GHz	dBc

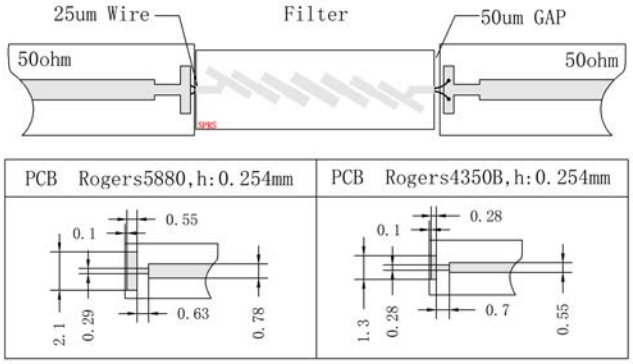
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

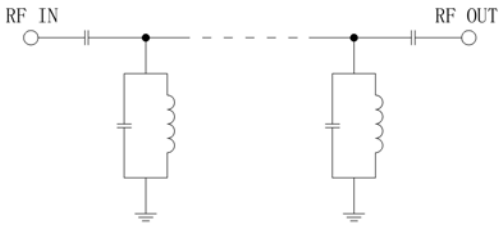
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

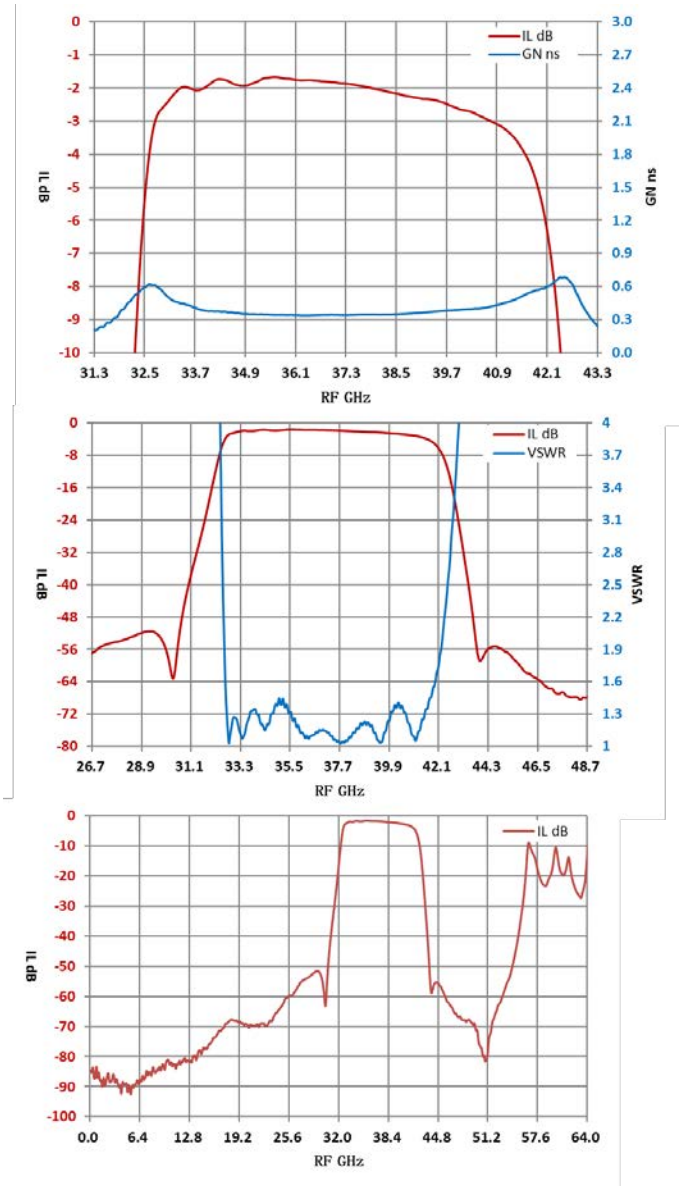
参考图



原理图



典型曲线



产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

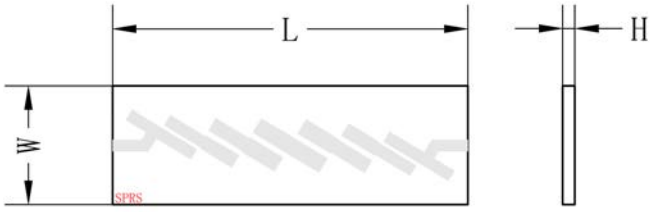
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	34.3	GHz
工作带宽	33.5-35.1	GHz
中心损耗	2.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-32.0GHz	dBc
带外抑制	40@36.8-47.0GHz	dBc

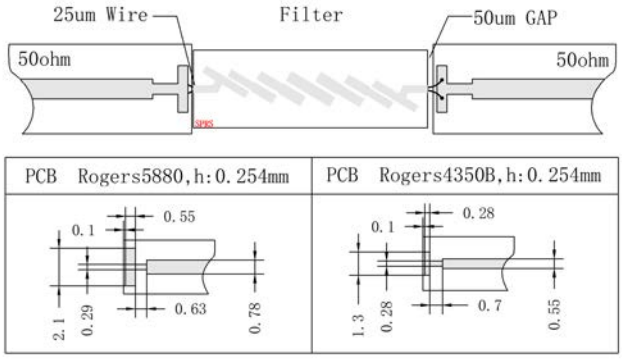
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



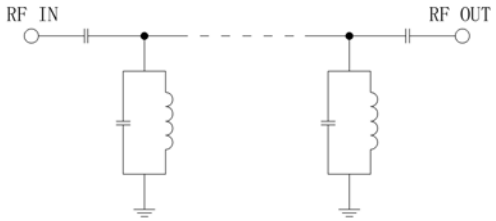
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

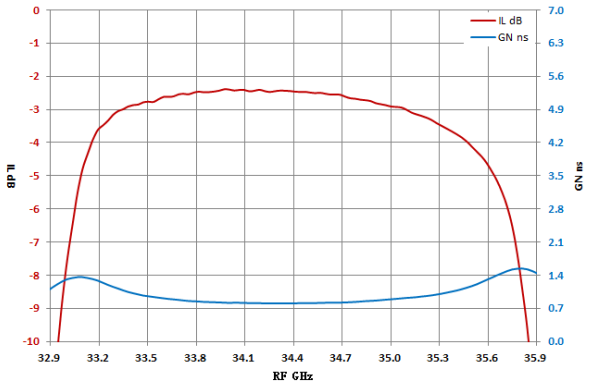
参考实物图

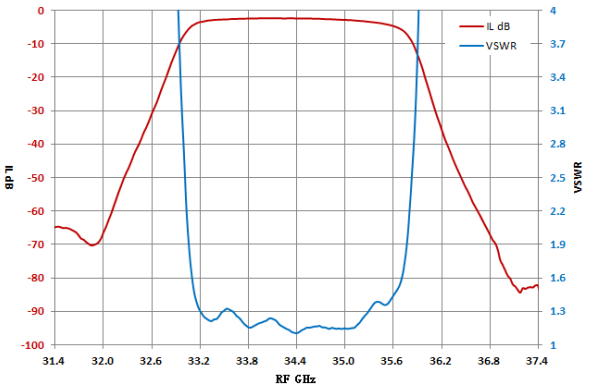


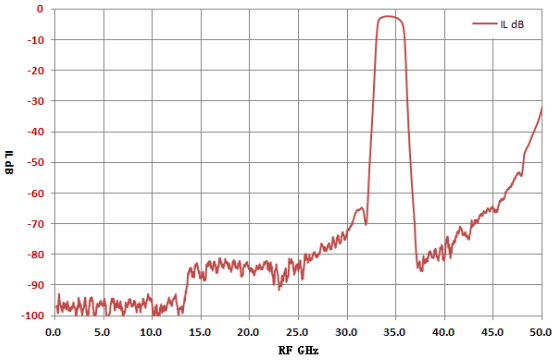
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

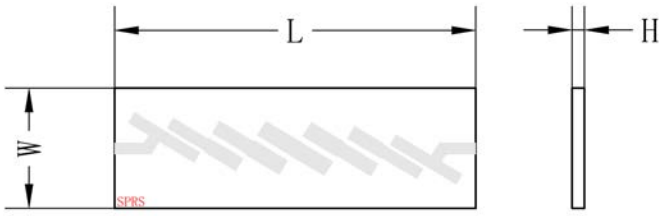
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	36.8	GHz
工作带宽	33.6-40.0	GHz
中心损耗	2.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-31.0GHz	dBc
带外抑制	40@43.6-51.0GHz	dBc

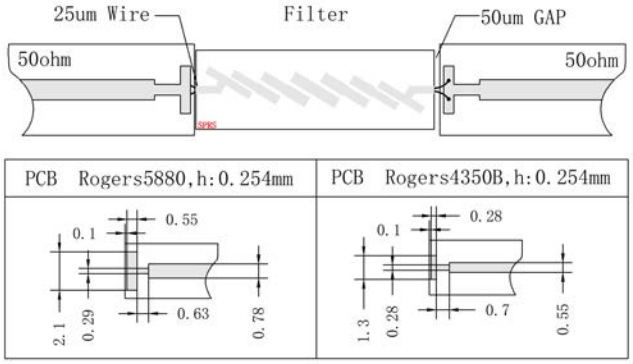
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

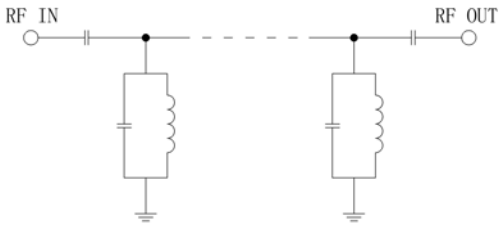
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

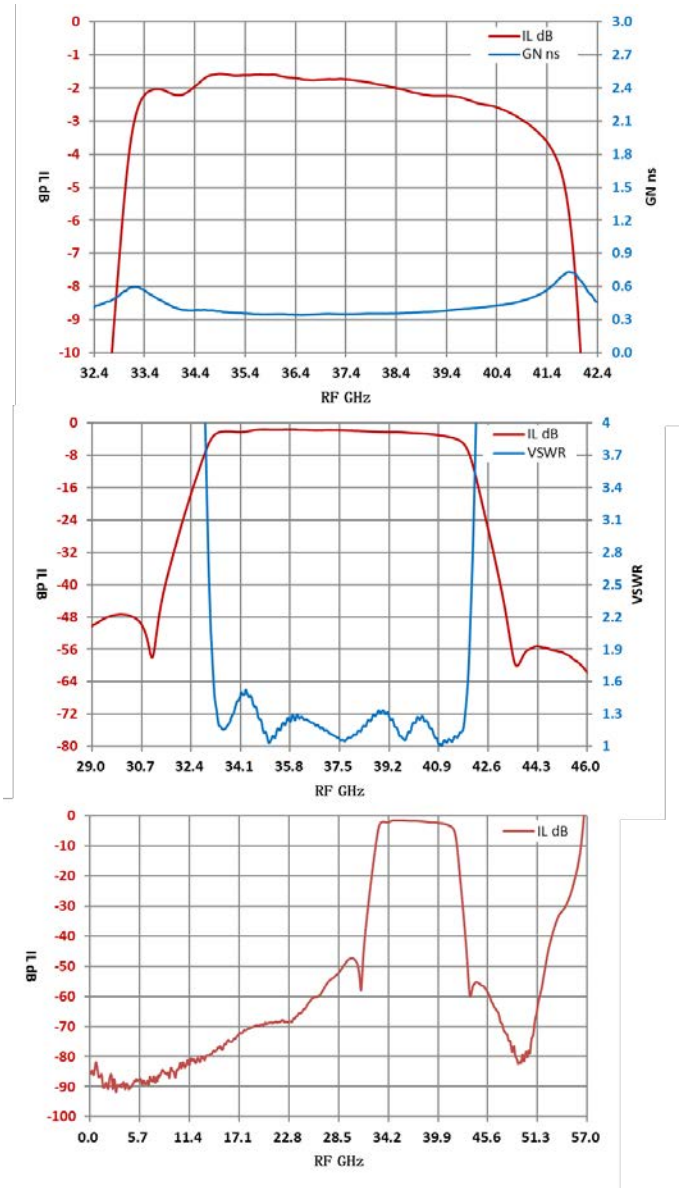
参考图



原理图



典型曲线



产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



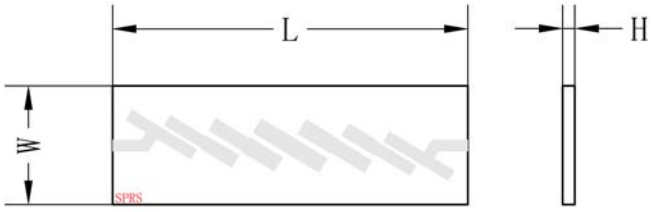
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	37.0	GHz
工作带宽	33.7-40.3	GHz
中心损耗	1.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-30.8GHz	dBc
带外抑制	30@43.4-47.0GHz	dBc

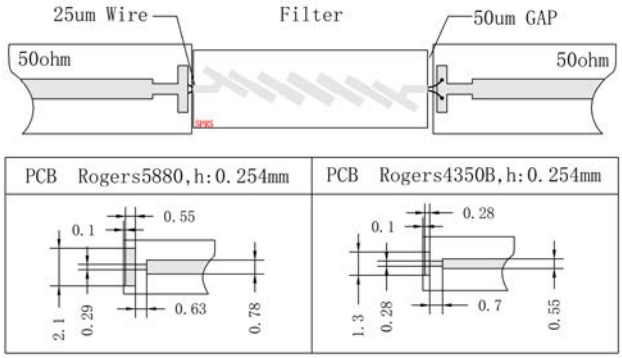
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



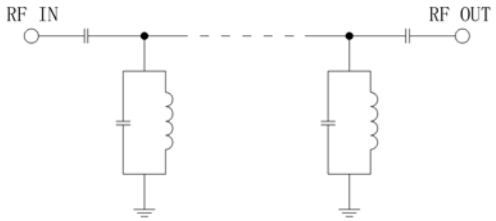
推荐装配图



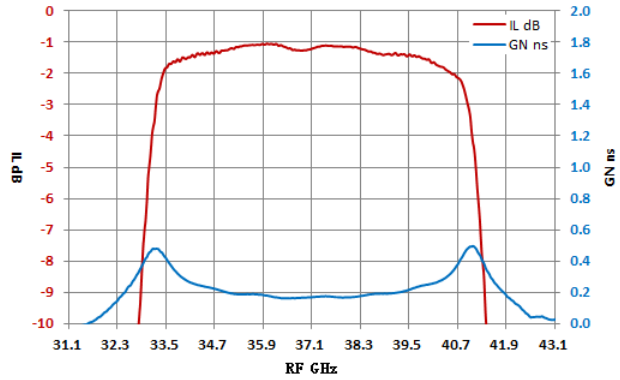
注意事项

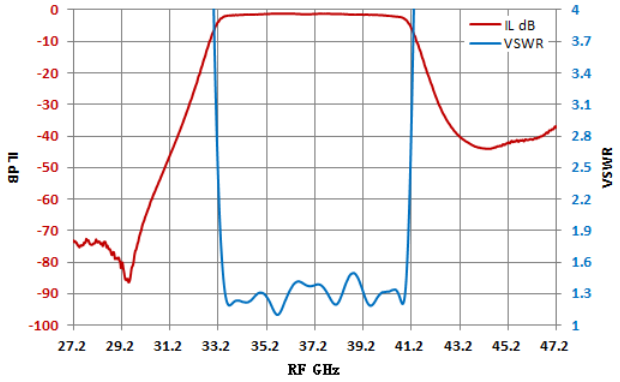
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

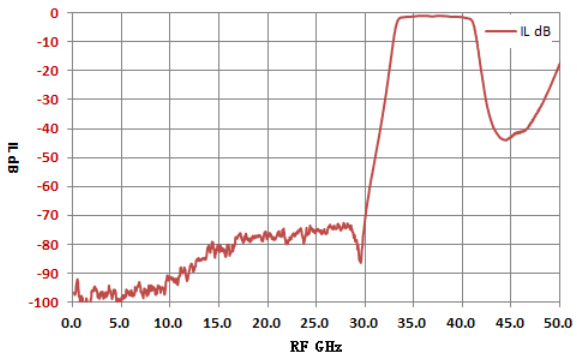
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



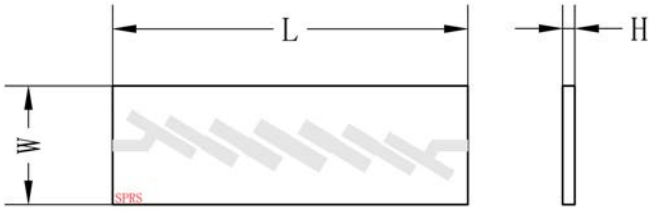
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	34.6	GHz
工作带宽	33.8-35.4	GHz
中心损耗	2.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-32.2GHz	dBc
带外抑制	40@37.0-48.0GHz	dBc

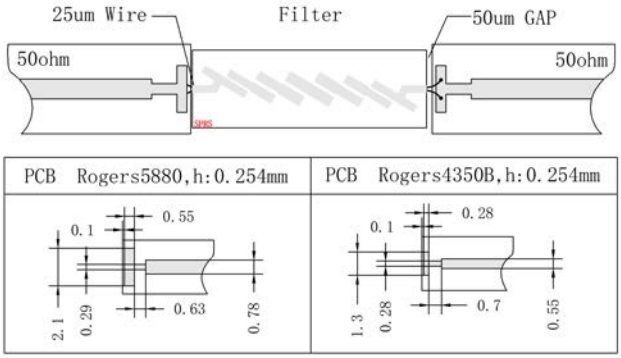
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



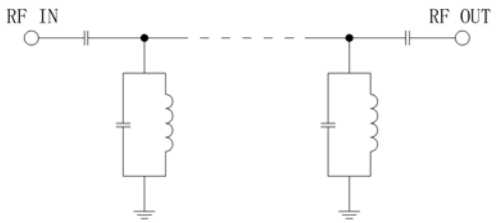
推荐装配图



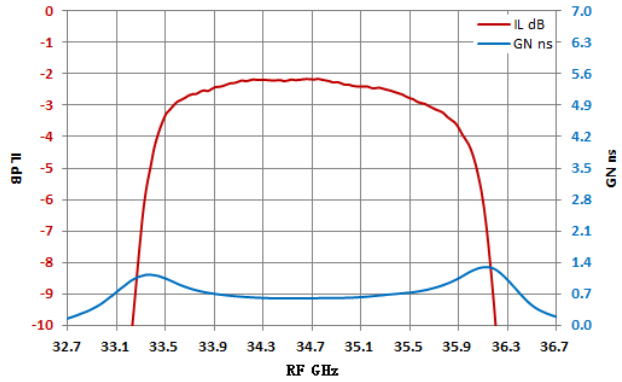
注意事项

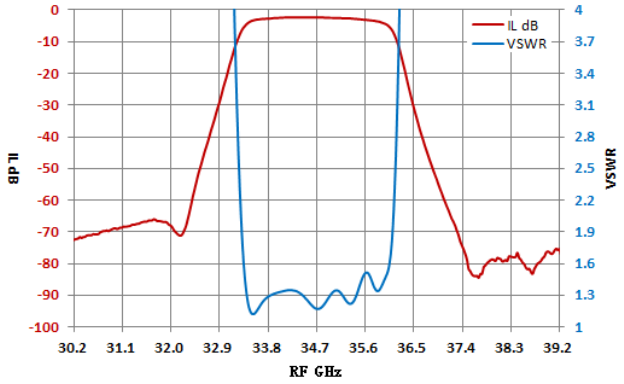
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

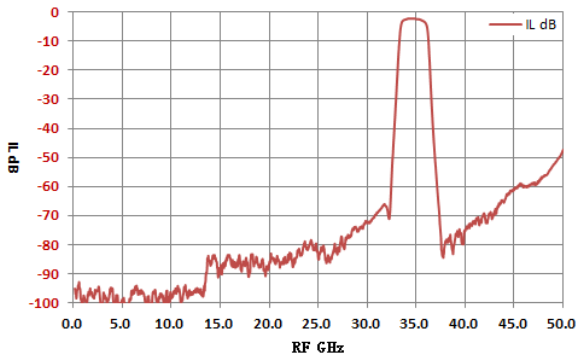
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



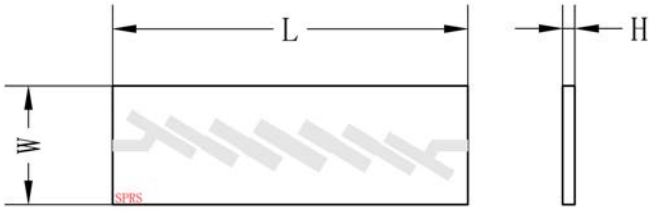
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	34.9	GHz
工作带宽	33.8-36.0	GHz
中心损耗	2.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-32.0GHz	dBc
带外抑制	40@38.0-43.0GHz	dBc

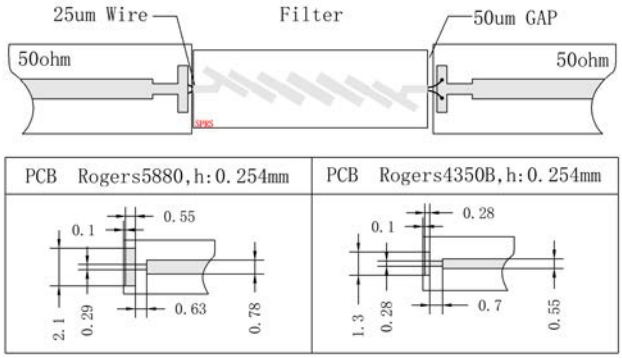
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



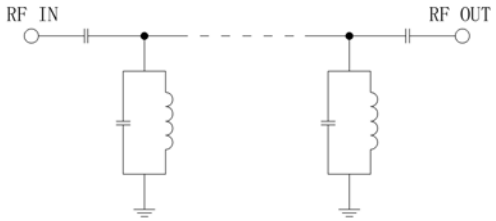
推荐装配图



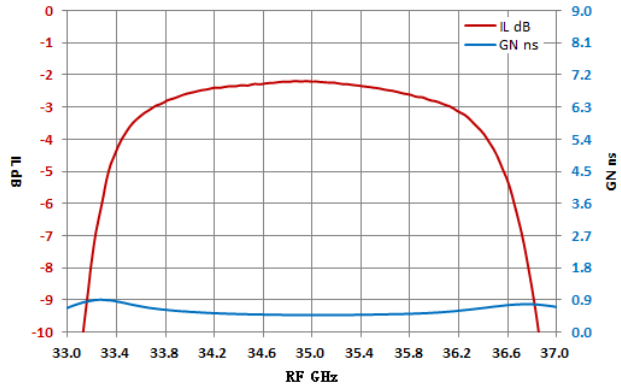
注意事项

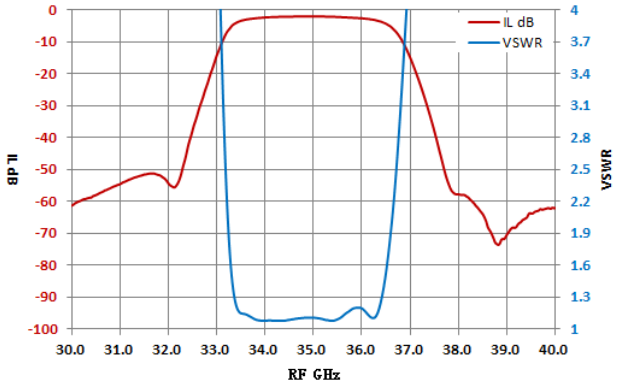
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

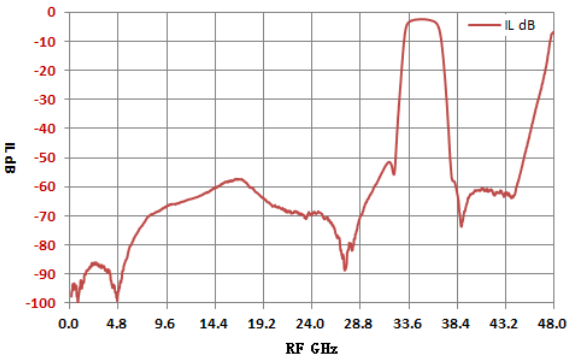
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

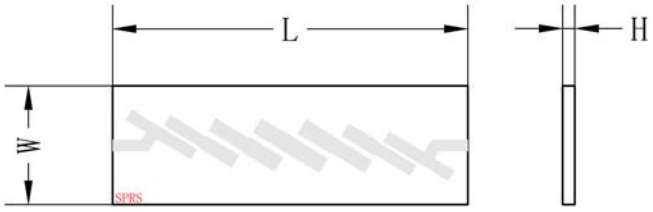
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	38.4	GHz
工作带宽	33.8-43.0	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-29.9GHz	dBc
带外抑制	40@50.1-54.0GHz	dBc

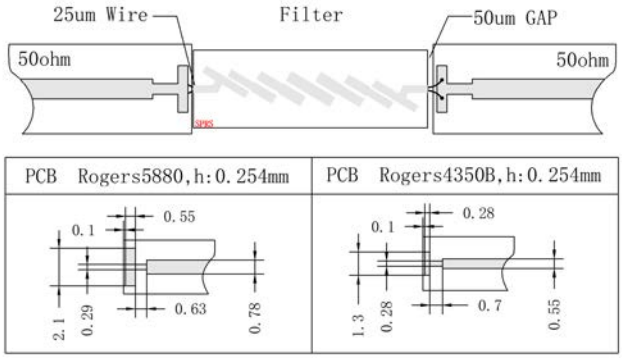
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



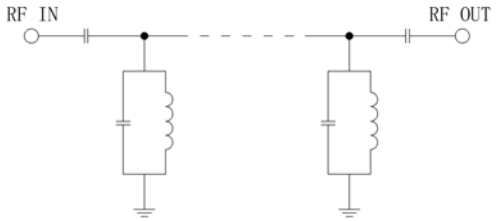
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

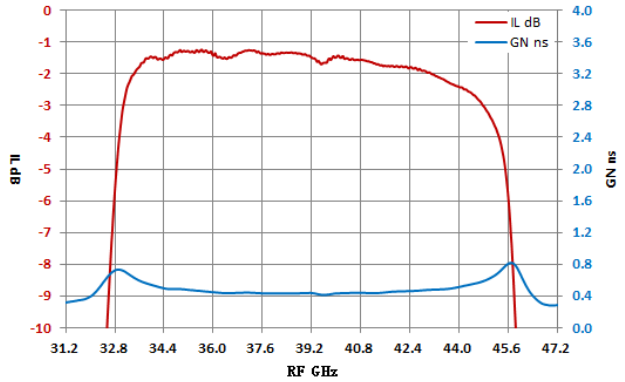
参考实物图

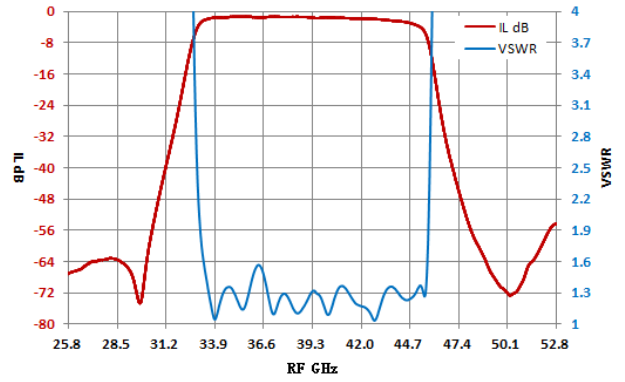


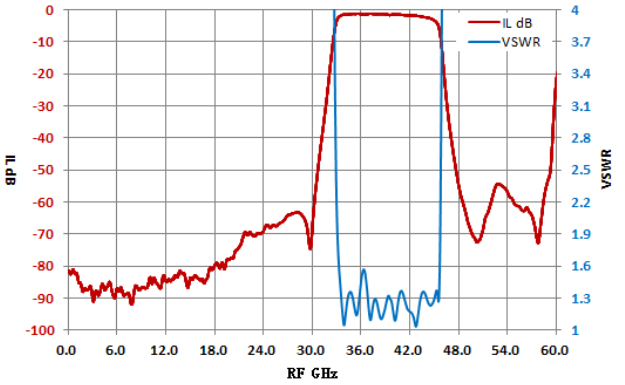
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

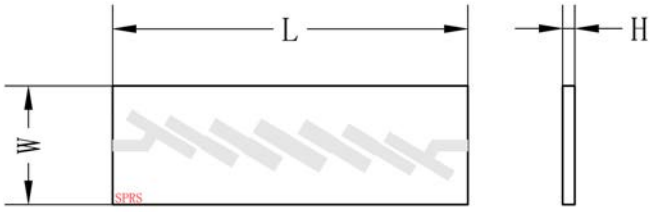
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	38.7	GHz
工作带宽	33.8-43.6	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-30.0GHz	dBc
带外抑制	40@48.4-54.0GHz	dBc

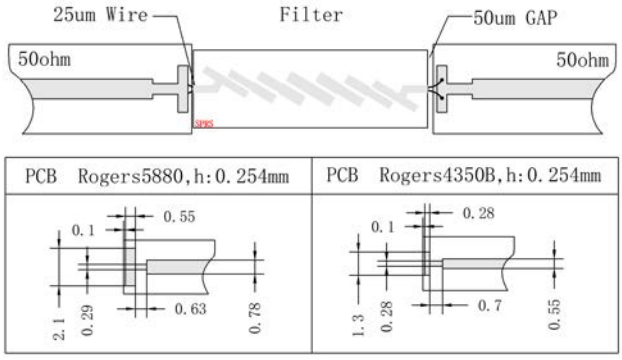
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



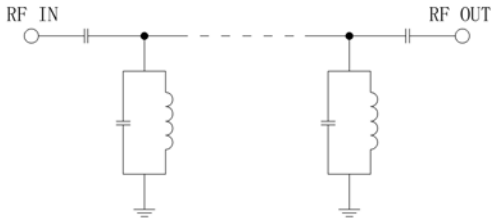
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

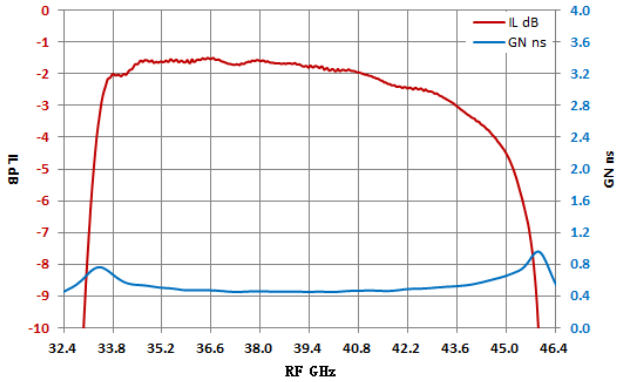
参考实物图

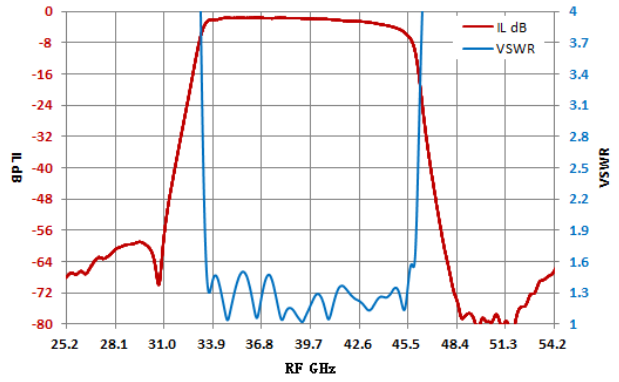


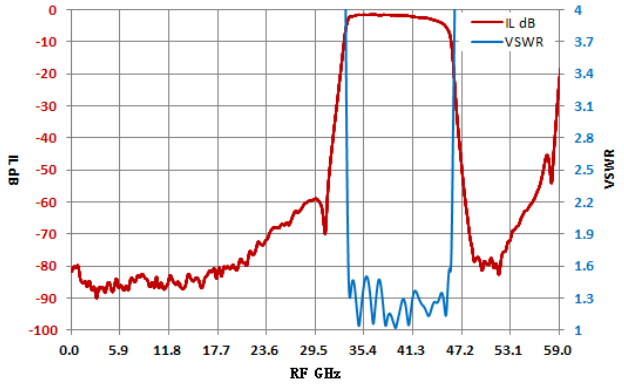
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



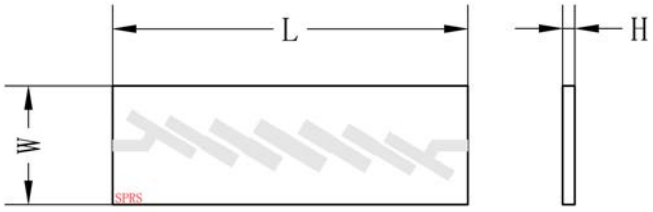
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	36.1	GHz
工作带宽	34.0-38.2	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-32.5GHz	dBc
带外抑制	40@40.5-46.0GHz	dBc

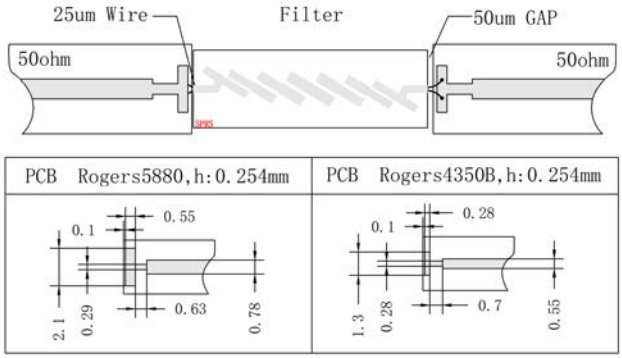
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



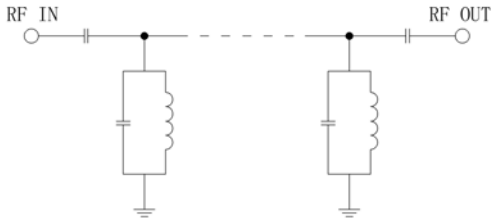
推荐装配图



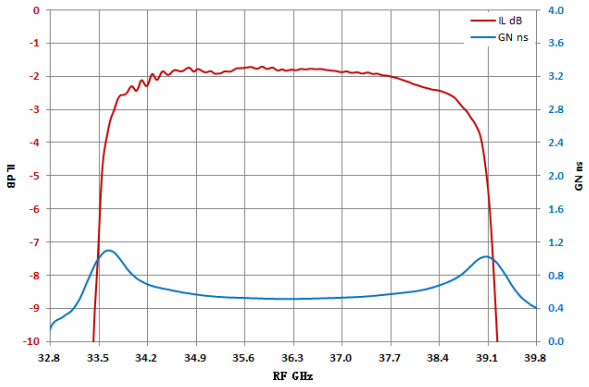
注意事项

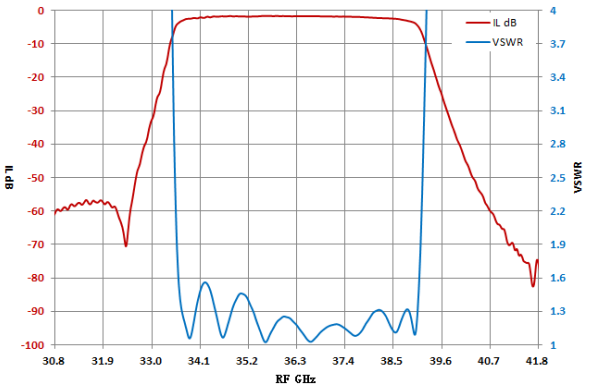
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

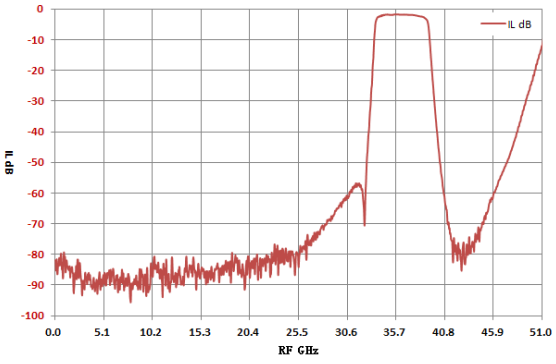
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



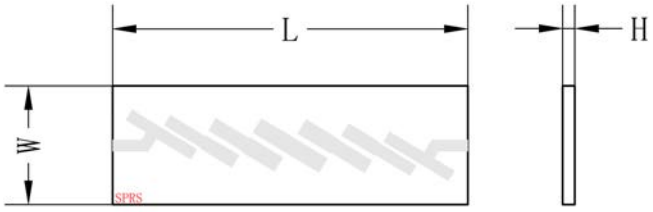
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	35.0	GHz
工作带宽	34.2-35.8	GHz
中心损耗	3.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-32.2GHz	dBc
带外抑制	40@38.0-44.0GHz	dBc

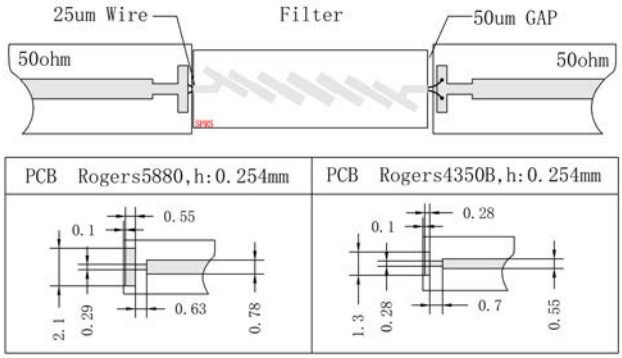
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



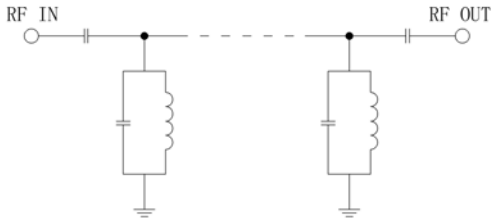
推荐装配图



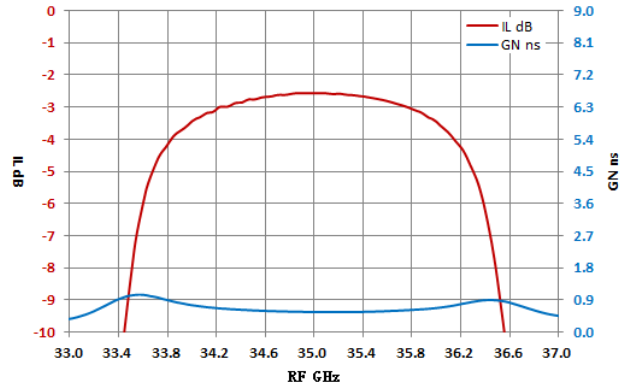
注意事项

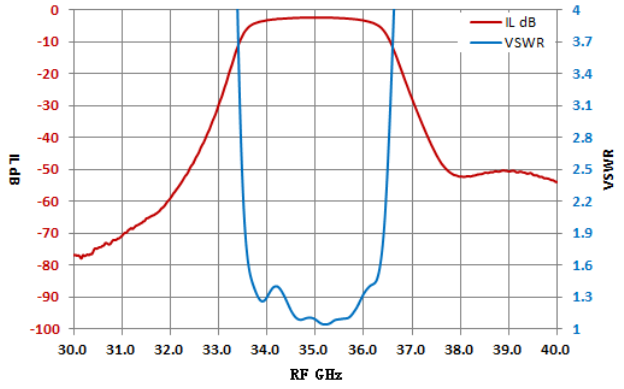
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

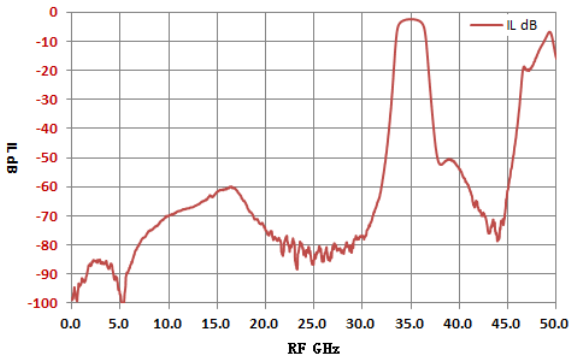
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



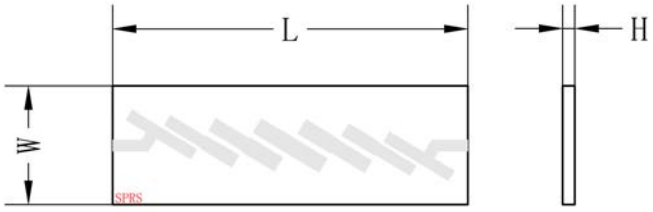
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	35.9	GHz
工作带宽	34.2-37.6	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-32.2GHz	dBc
带外抑制	40@40.0-45.0GHz	dBc

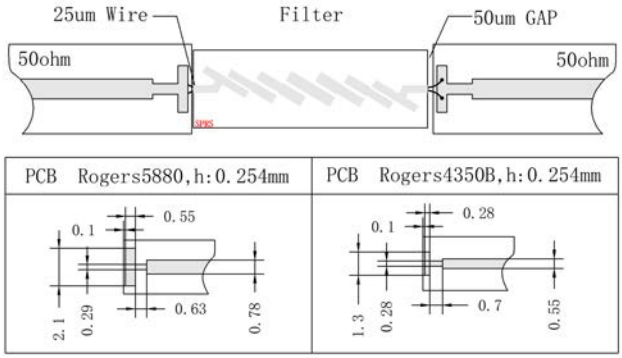
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



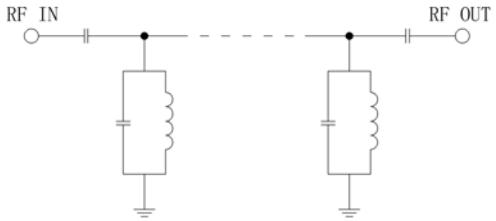
推荐装配图



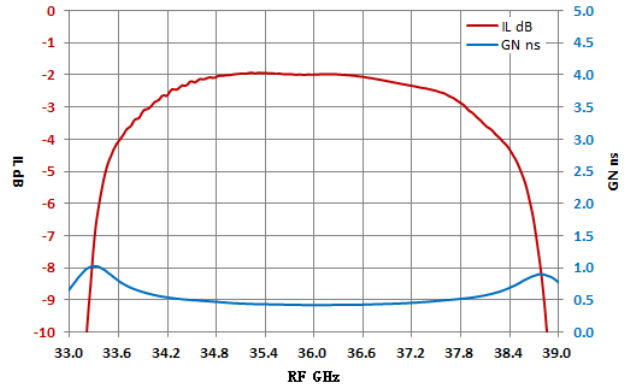
注意事项

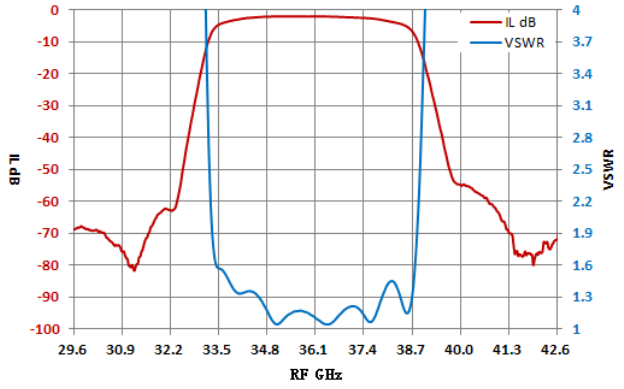
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

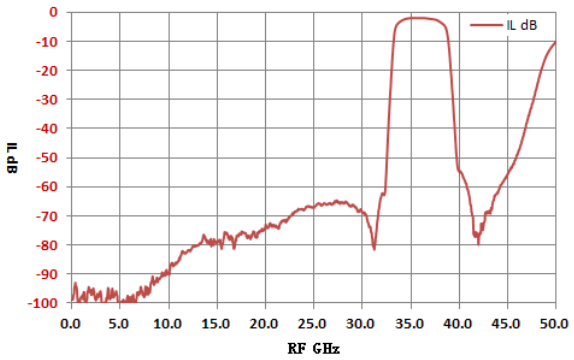
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

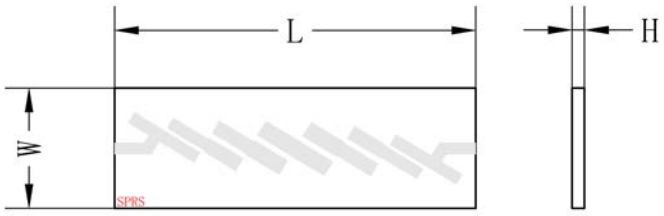
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	36.2	GHz
工作带宽	34.2-38.2	GHz
中心损耗	2.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	35@DC-31.4GHz	dBc
带外抑制	35@40.9-56.0GHz	dBc

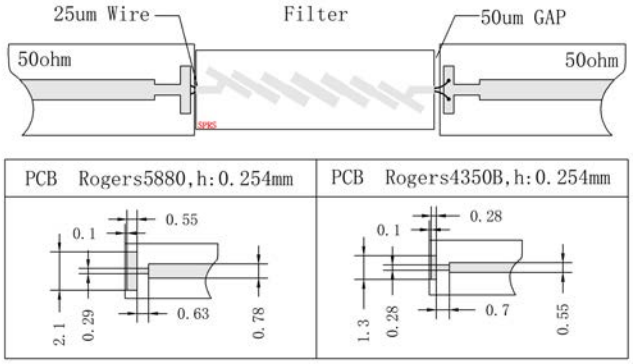
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：6.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

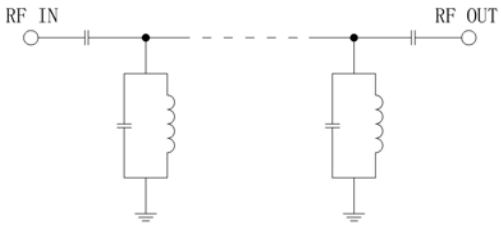
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

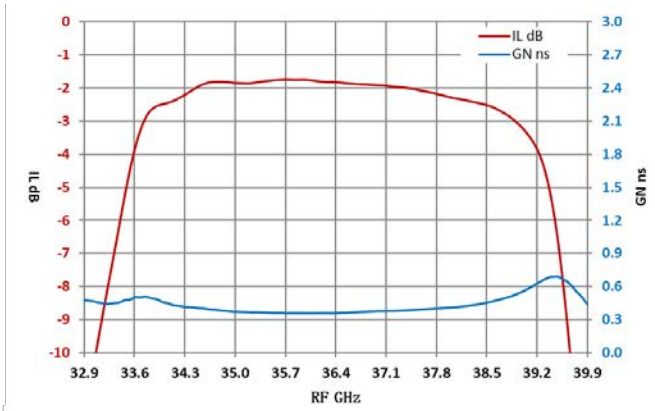
参考图

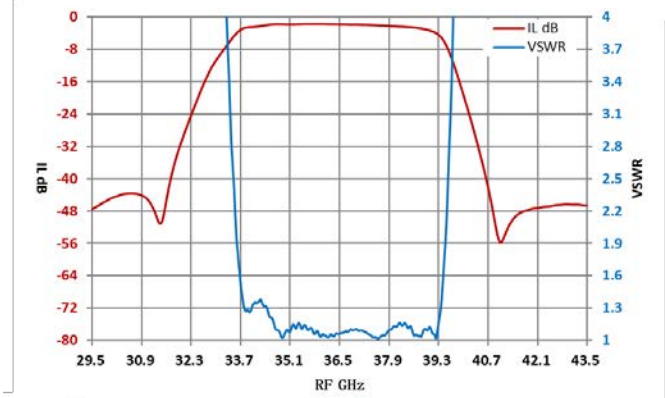


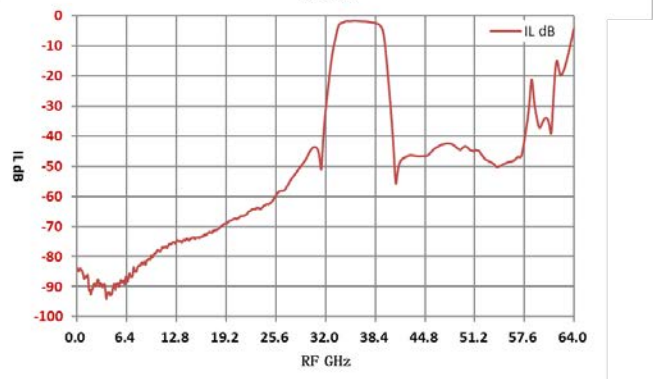
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

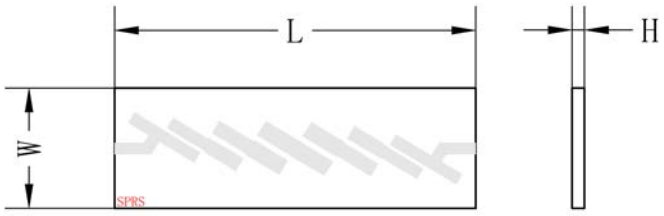
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	36.3	GHz
工作带宽	34.3-38.3	GHz
中心损耗	2.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	35@DC-32.1GHz	dBc
带外抑制	35@41.2-56.0GHz	dBc

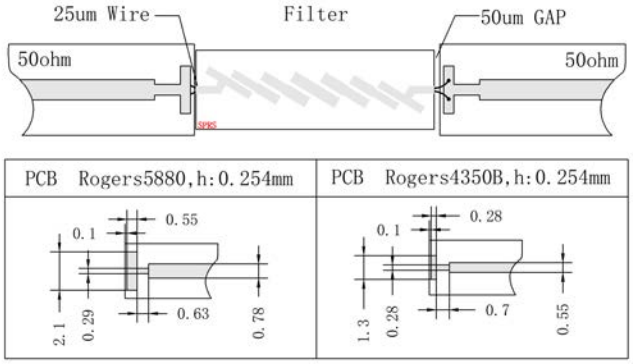
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：5.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

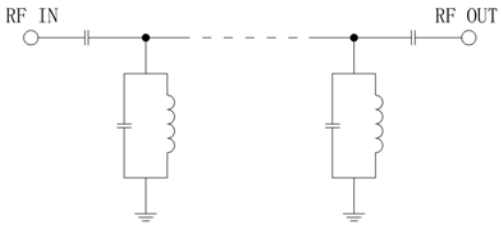
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

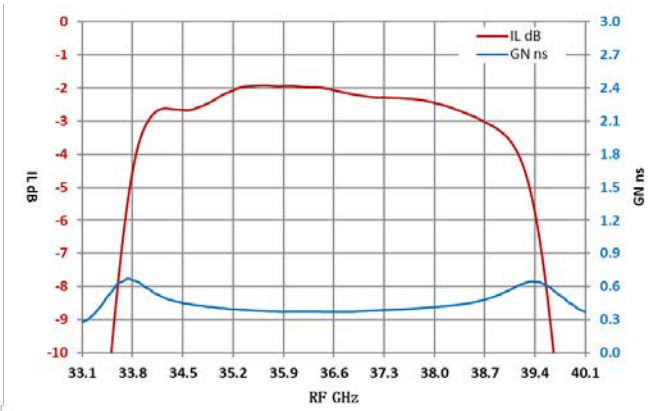
参考图

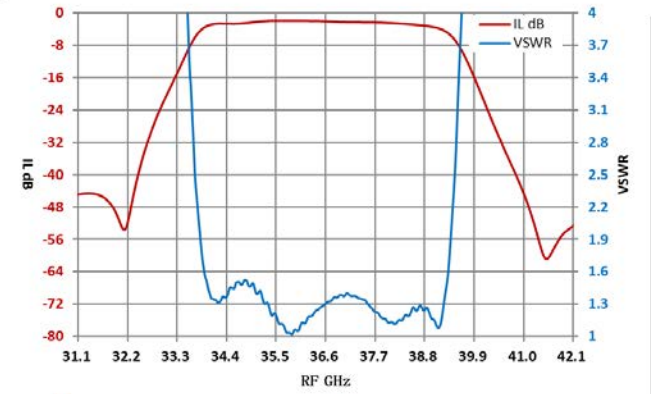


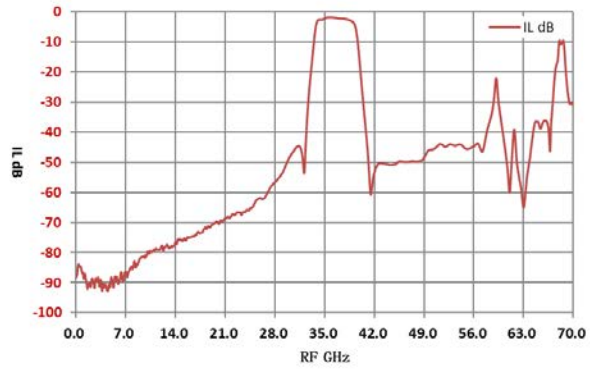
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

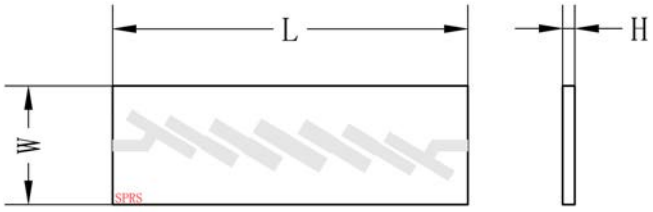
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	37.5	GHz
工作带宽	34.6-40.4	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	04	ns
带外抑制	40@DC-31.4GHz	dBc
带外抑制	40@43.9-50.0GHz	dBc

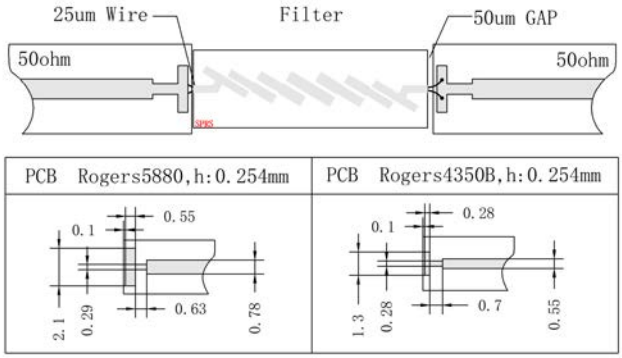
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



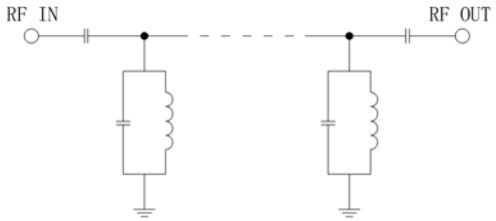
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

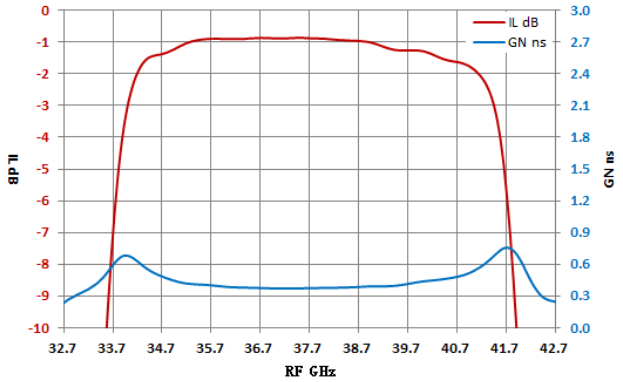
参考实物图

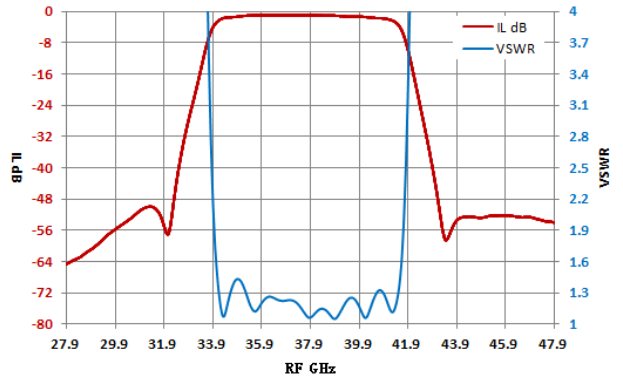


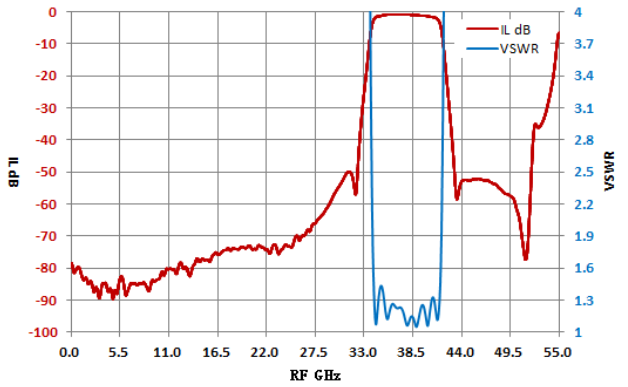
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



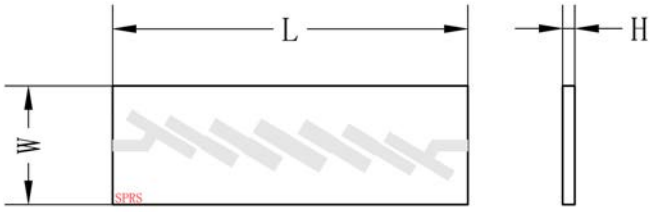
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	38.6	GHz
工作带宽	34.7-42.5	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-31.0GHz	dBc
带外抑制	40@47.5-54.0GHz	dBc

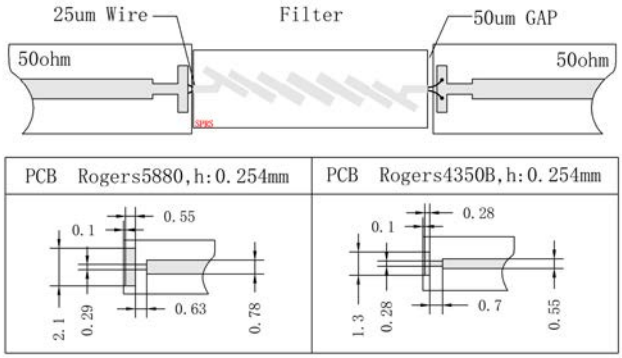
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



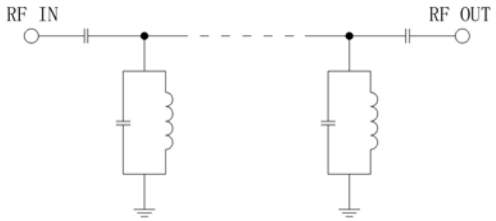
推荐装配图



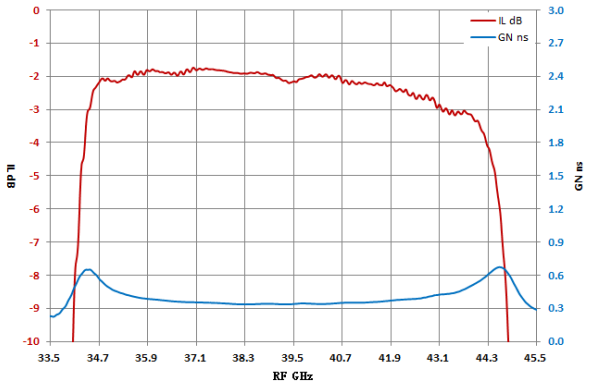
注意事项

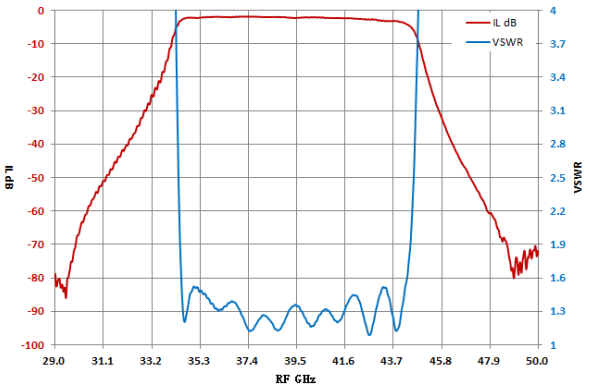
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

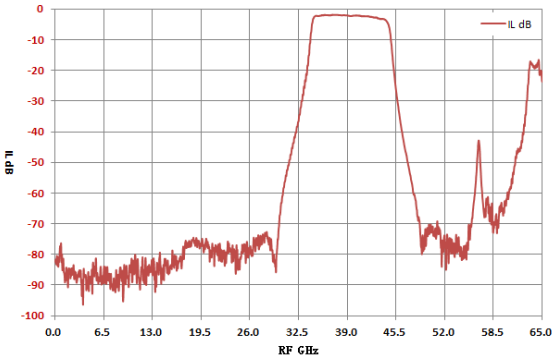
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



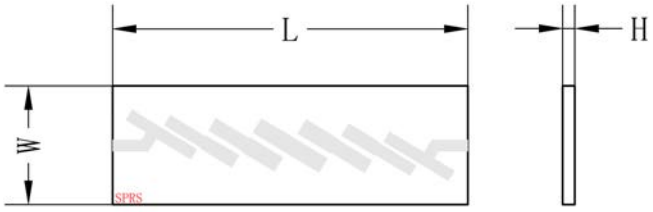
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	35.8	GHz
工作带宽	34.8-36.8	GHz
中心损耗	2.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-33.2GHz	dBc
带外抑制	40@38.8-45.0GHz	dBc

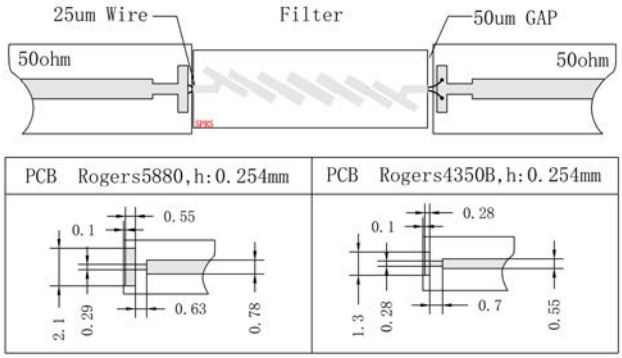
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：5.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



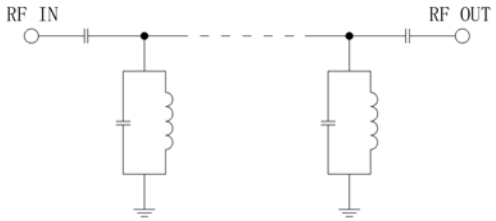
推荐装配图



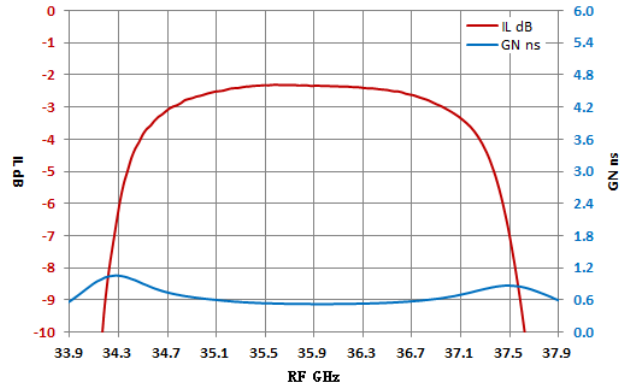
注意事项

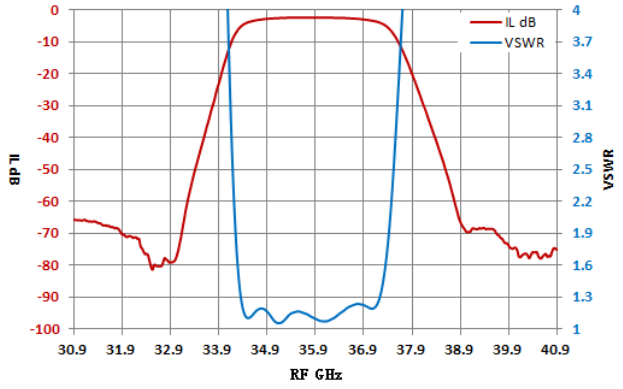
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

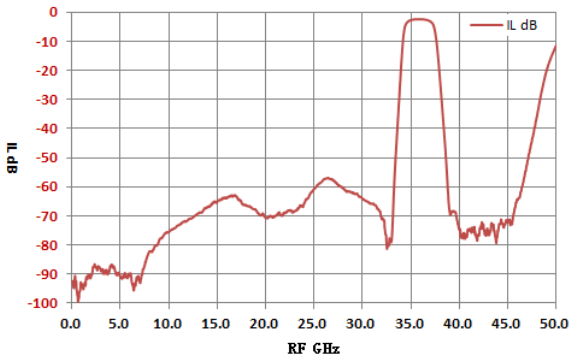
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



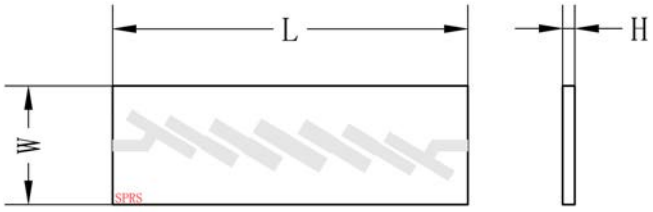
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	36.3	GHz
工作带宽	34.8-37.8	GHz
中心损耗	2.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-33.2GHz	dBc
带外抑制	40@40.0-45.0GHz	dBc

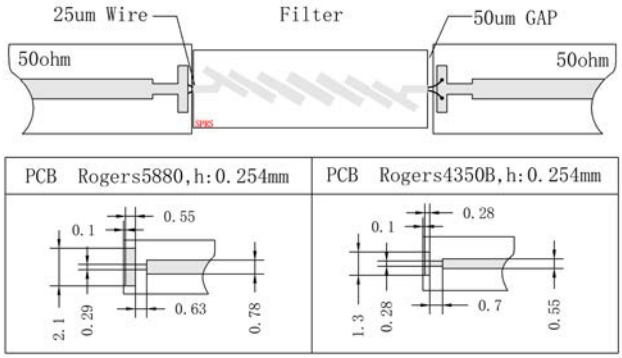
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



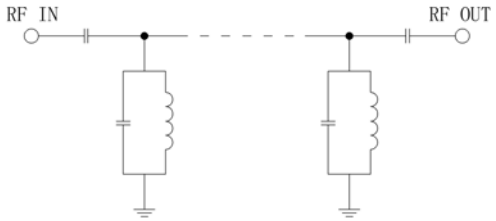
推荐装配图



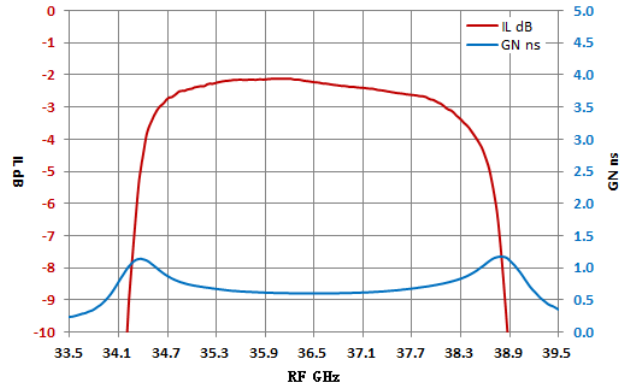
注意事项

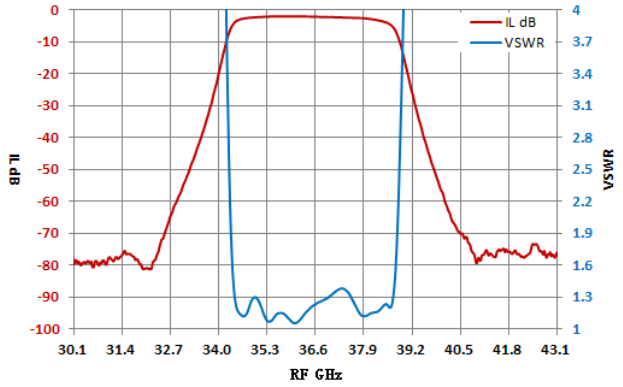
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

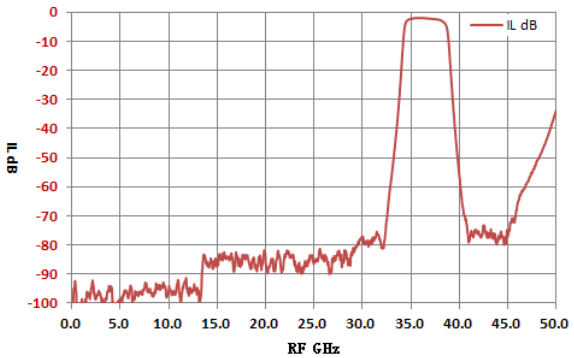
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



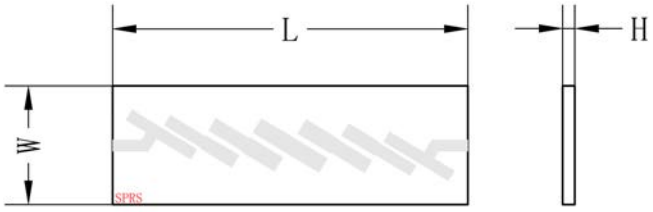
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	37.4	GHz
工作带宽	34.8-40.0	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-32.6GHz	dBc
带外抑制	40@42.8-50.0GHz	dBc

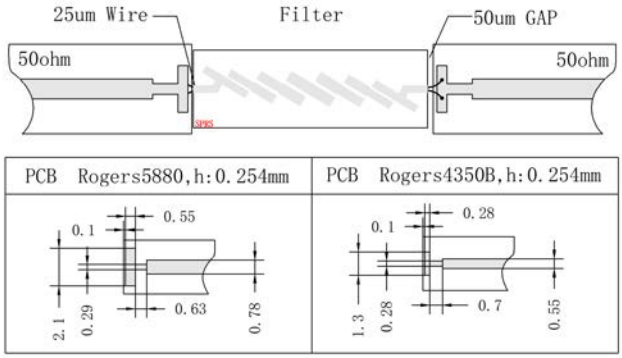
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



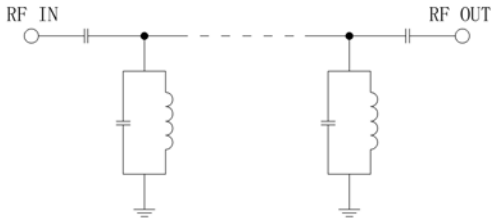
推荐装配图



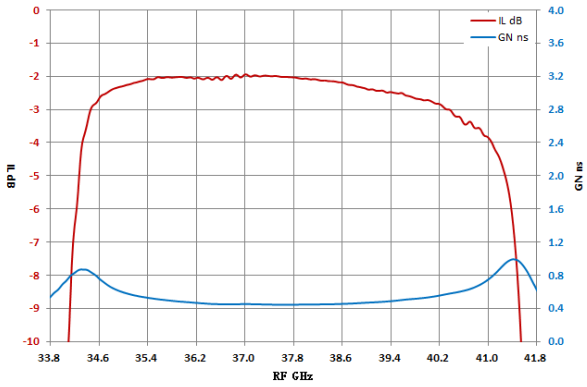
注意事项

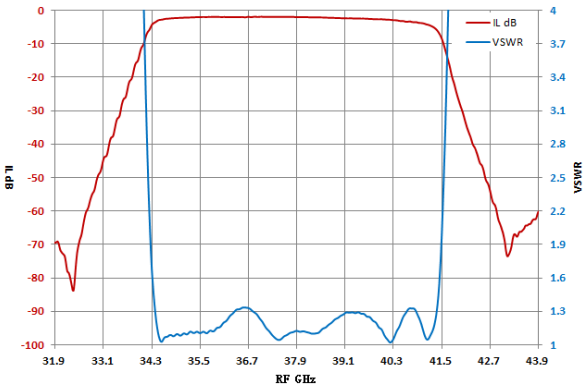
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

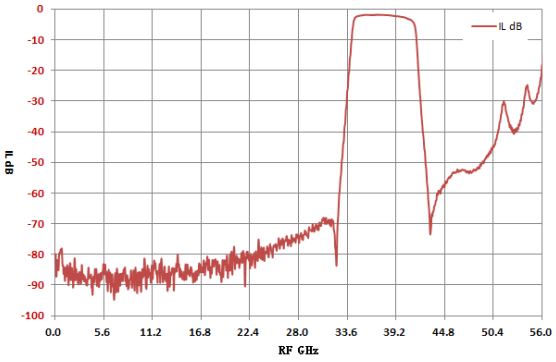
原理图



典型曲线







陶瓷滤波器 STBP358-1R8-K585

工作带宽 34.9-36.7GHz,带外抑制 40@DC-33.2GHz,40@38.6-45.0GHz

产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



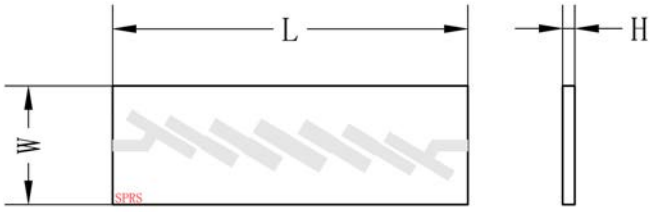
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	35.8	GHz
工作带宽	34.9-36.7	GHz
中心损耗	2.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-33.2GHz	dBc
带外抑制	40@38.6-45.0GHz	dBc

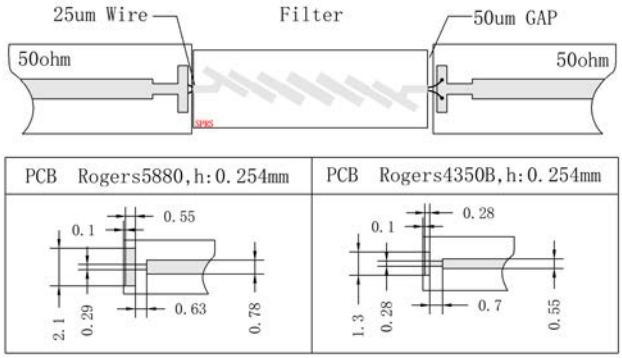
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



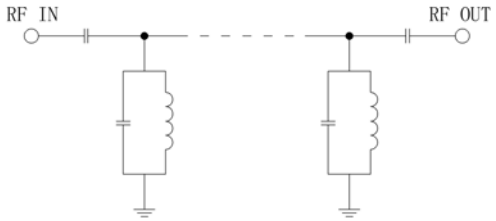
推荐装配图



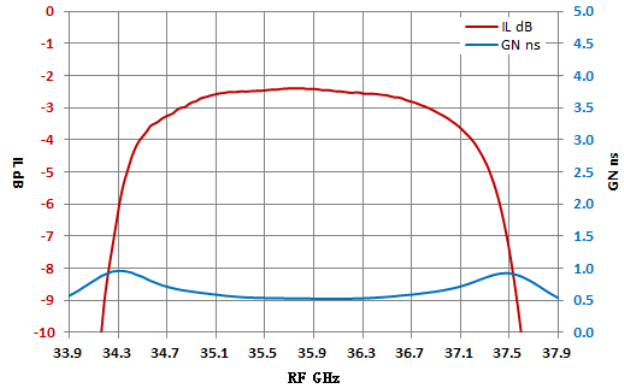
注意事项

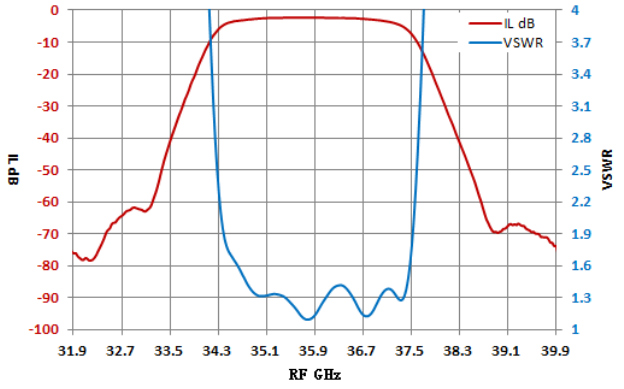
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

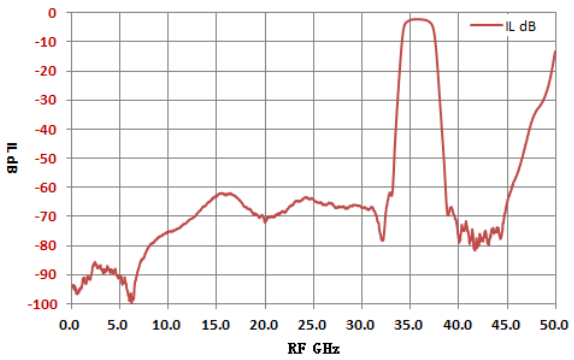
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



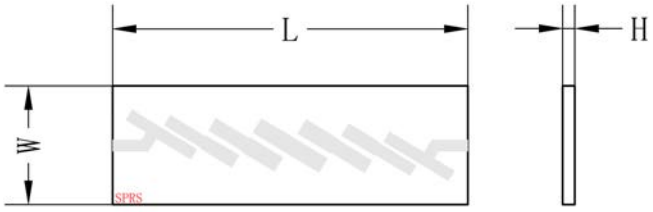
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	36.0	GHz
工作带宽	35.0-37.0	GHz
中心损耗	3.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-32.8GHz	dBc
带外抑制	40@39.2-44.0GHz	dBc

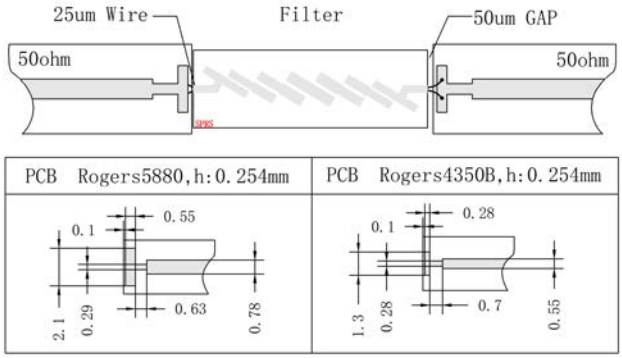
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



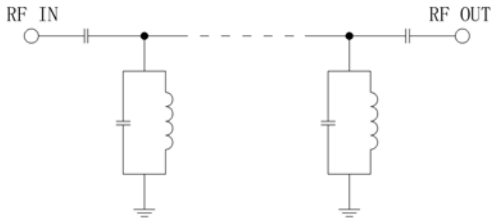
推荐装配图



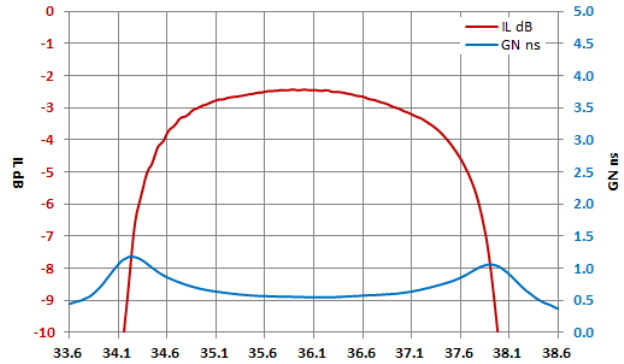
注意事项

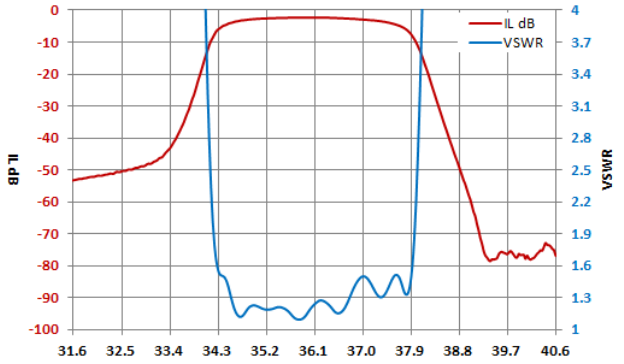
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

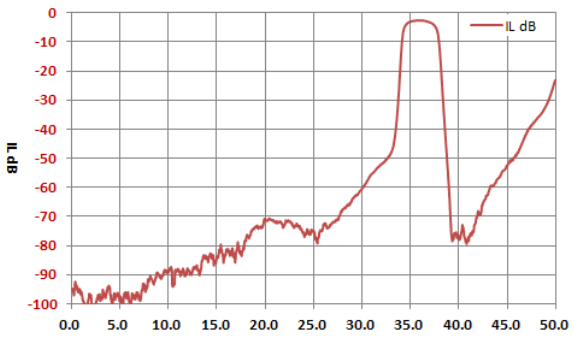
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



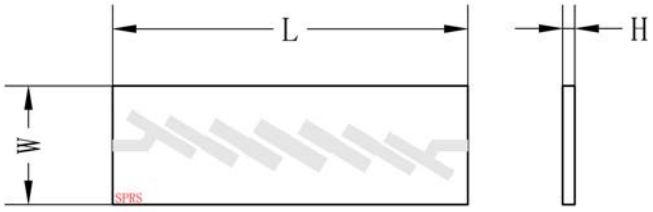
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	37.2	GHz
工作带宽	35.0-39.3	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-33.2GHz	dBc
带外抑制	40@42.0-48.0GHz	dBc

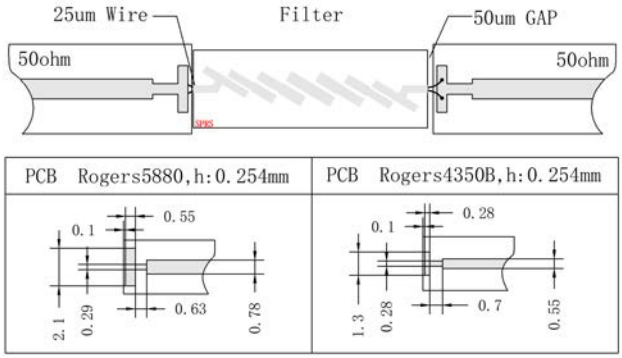
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



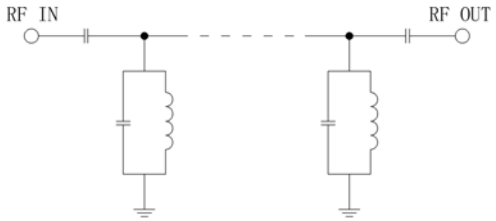
推荐装配图



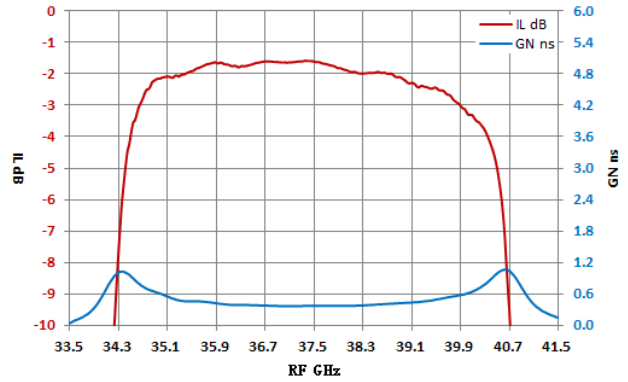
注意事项

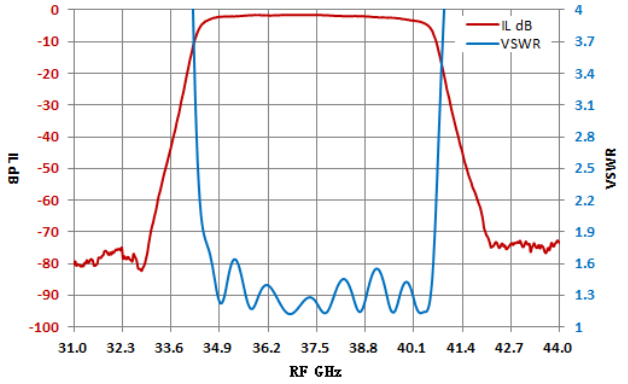
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.25mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

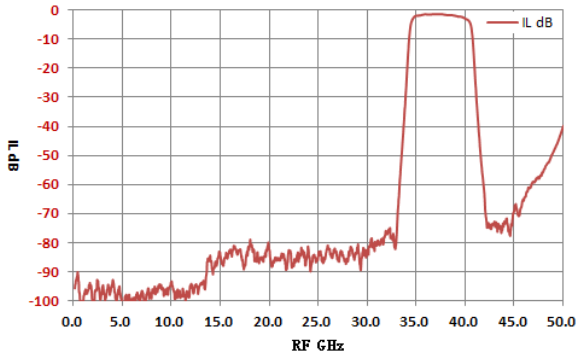
原理图



典型曲线







陶瓷滤波器 STBP383-6R6-K685

工作带宽 35.0-41.6GHz,带外抑制 40@DC-33.0GHz,40@45.0-49.0GHz

产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



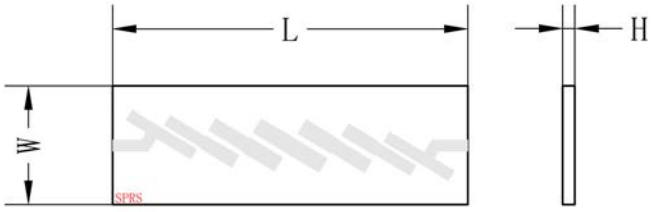
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	38.3	GHz
工作带宽	35.0-41.6	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-33.0GHz	dBc
带外抑制	40@45.0-49.0GHz	dBc

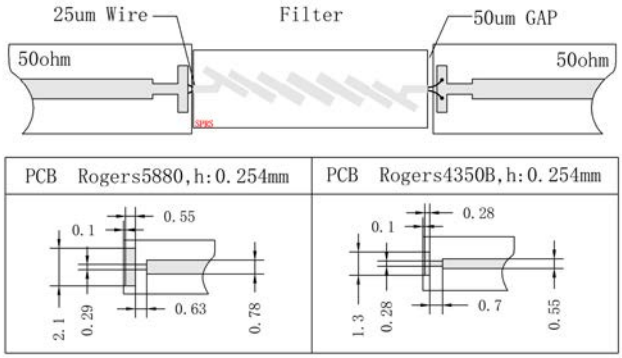
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



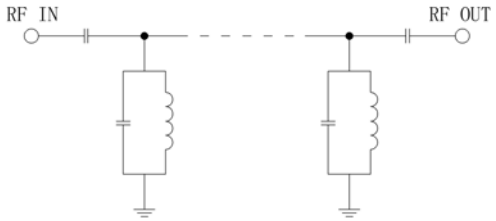
推荐装配图



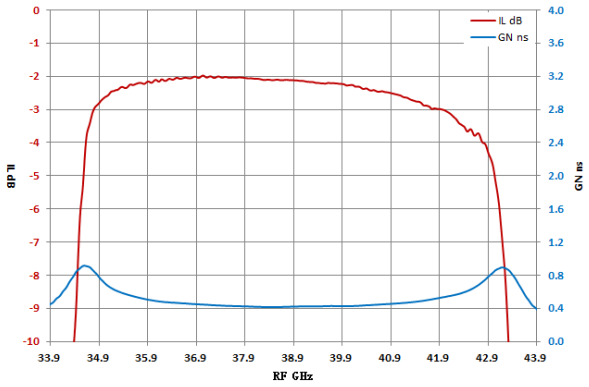
注意事项

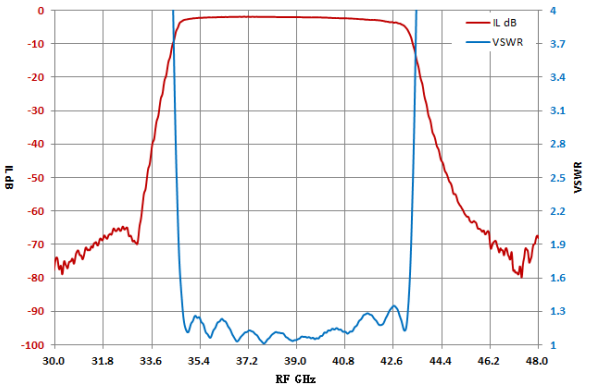
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

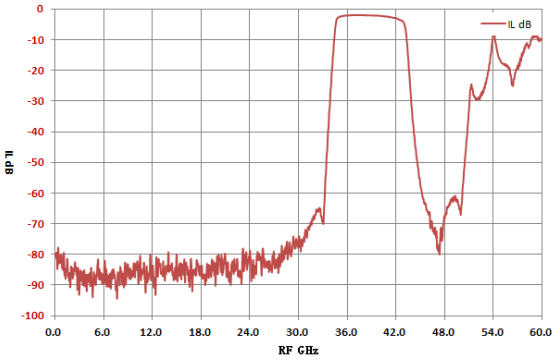
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



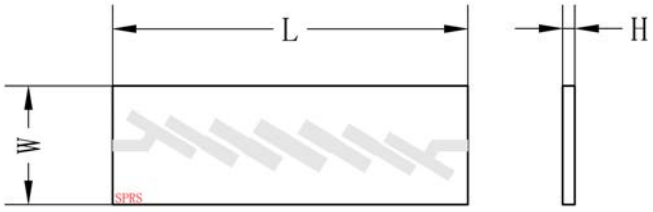
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	38.2	GHz
工作带宽	35.2-41.2	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-33.2GHz	dBc
带外抑制	40@43.4-49.0GHz	dBc

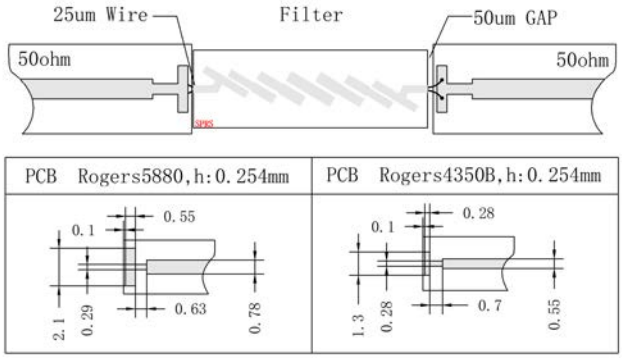
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



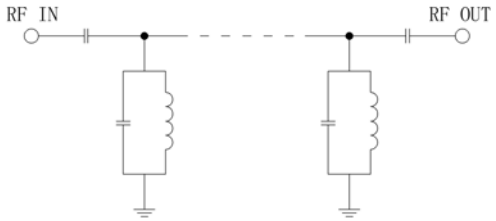
推荐装配图



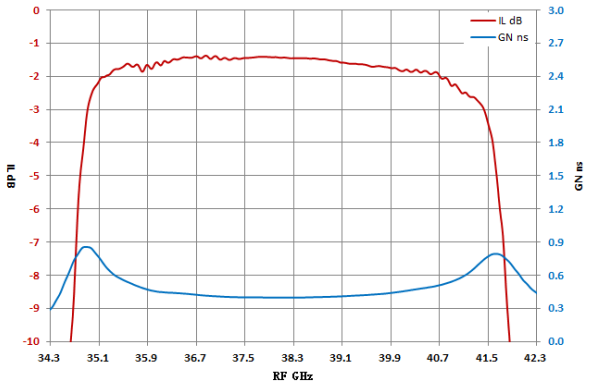
注意事项

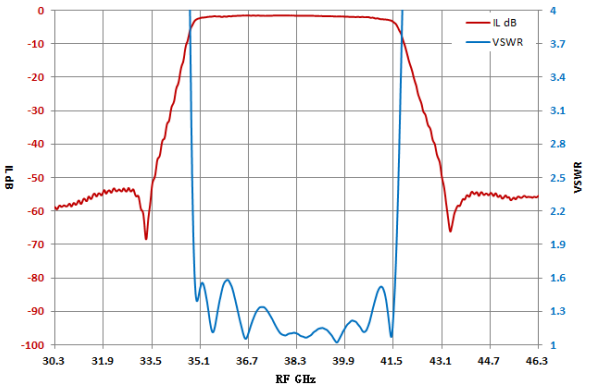
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

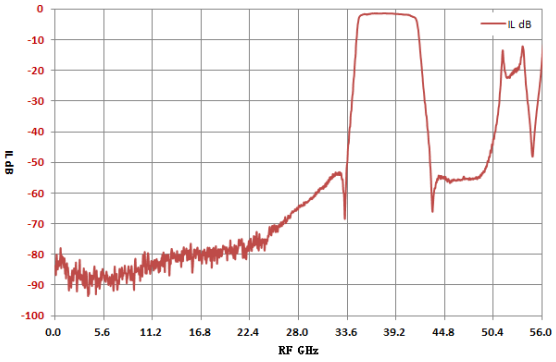
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

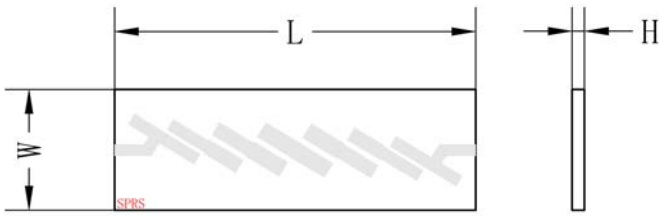
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	35.55	GHz
工作带宽	35.3-35.8	GHz
中心损耗	4.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	20@DC-33.5GHz	dBc
带外抑制	10@37.1-49.0GHz	dBc

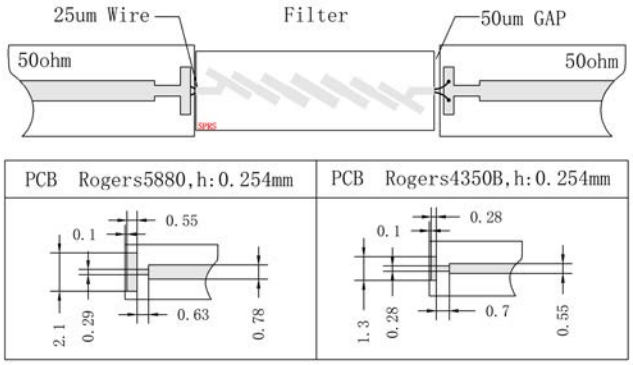
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：4.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

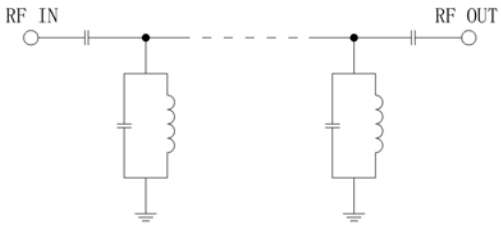
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

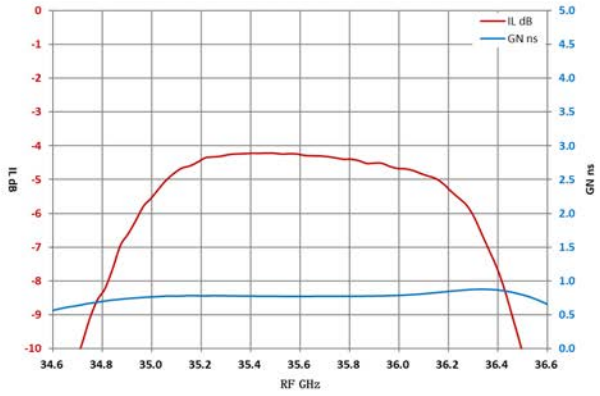
参考图

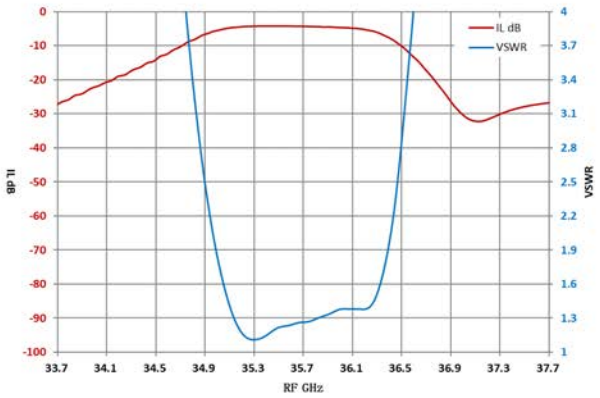


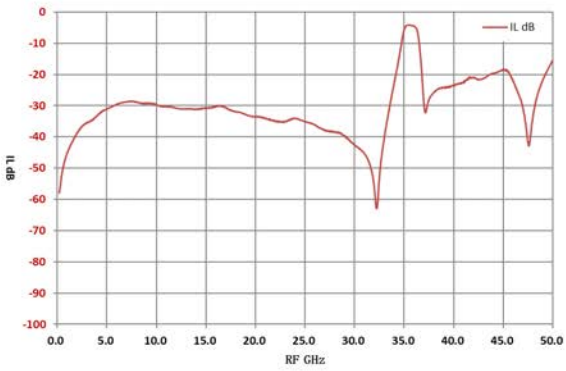
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

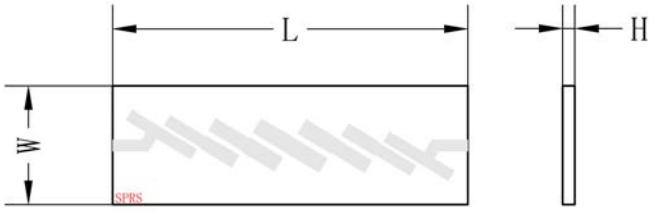
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	36.9	GHz
工作带宽	35.3-38.5	GHz
中心损耗	2.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-33.1GHz	dBc
带外抑制	40@41.2-43.6GHz	dBc

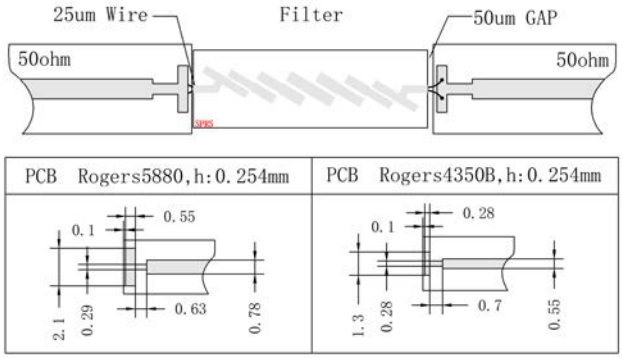
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：2，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



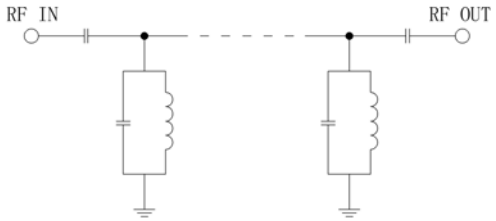
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

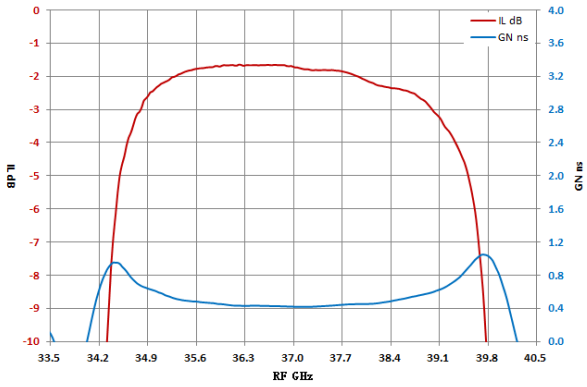
参考实物图

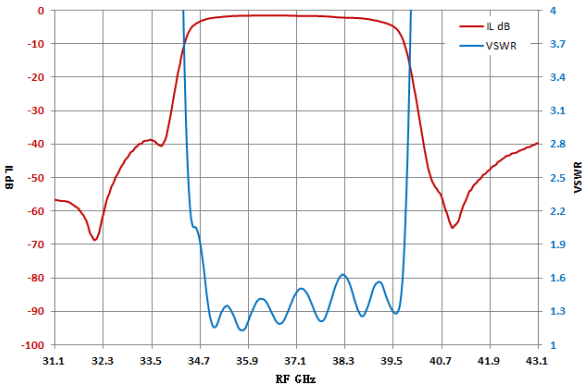


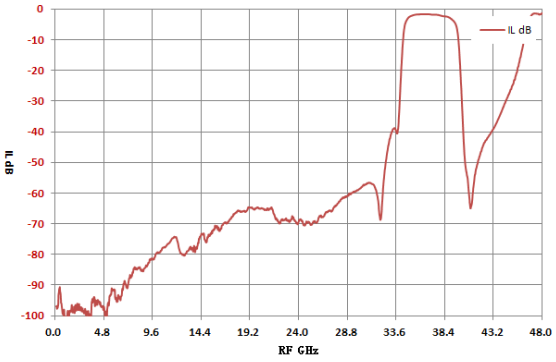
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



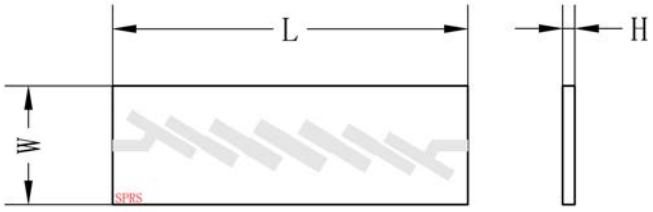
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	37.0	GHz
工作带宽	35.5-38.5	GHz
中心损耗	2.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	30@DC-33.6GHz	dBc
带外抑制	30@41.0-42.0GHz	dBc

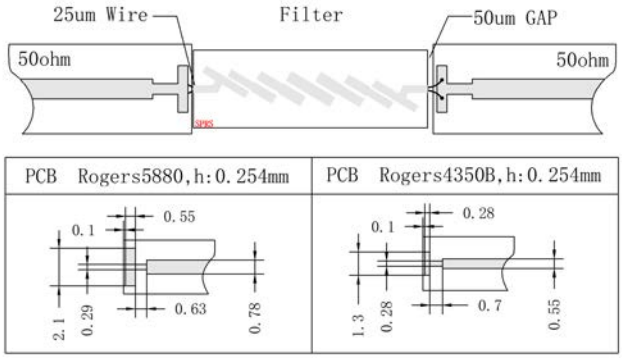
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



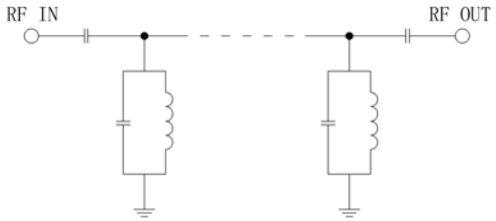
推荐装配图



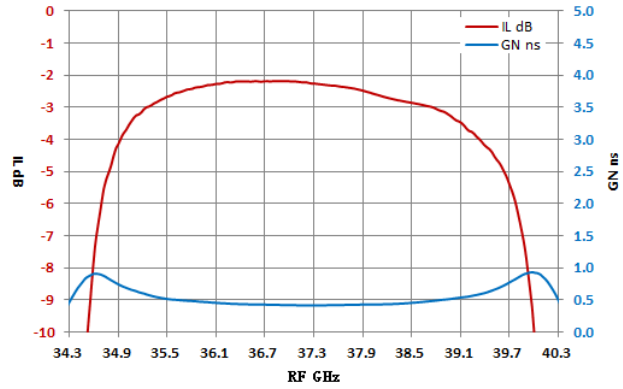
注意事项

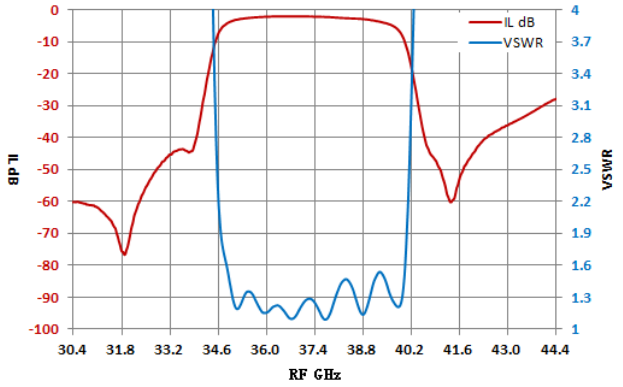
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

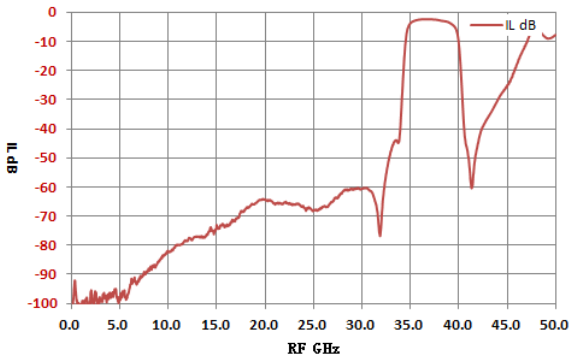
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

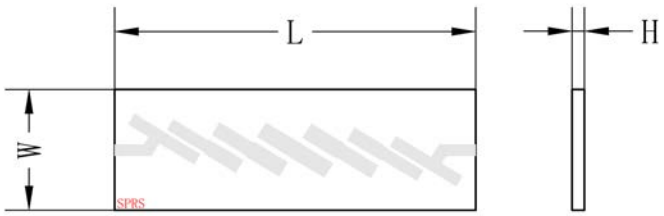
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	35.8	GHz
工作带宽	35.6-36.0	GHz
中心损耗	4.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	20@DC-34.2GHz	dBc
带外抑制	10@37.2-50.0GHz	dBc

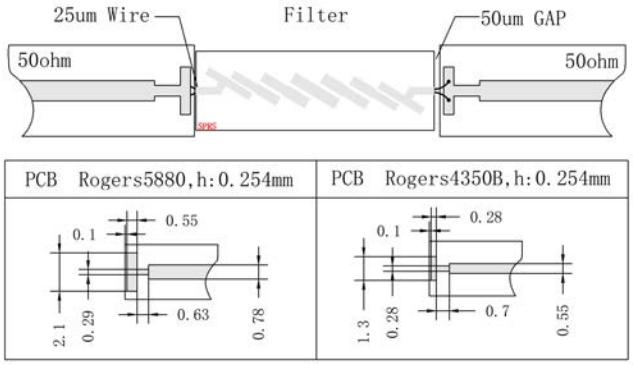
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：4.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

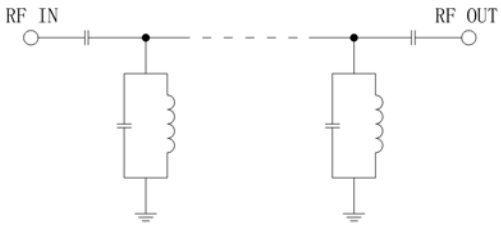
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

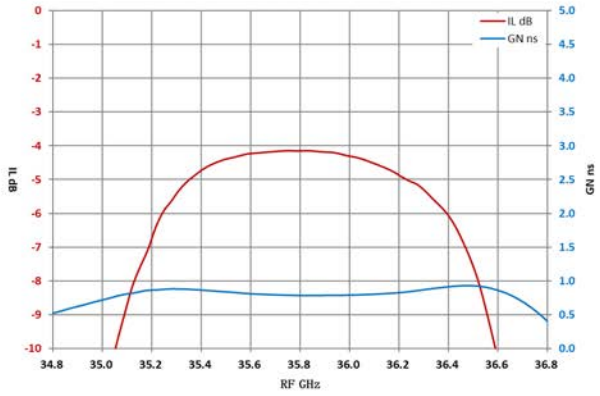
参考图

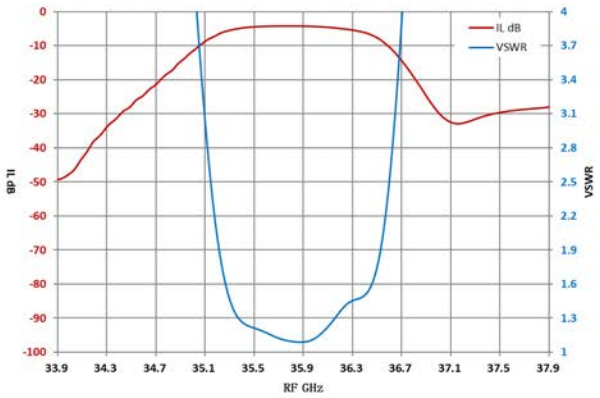


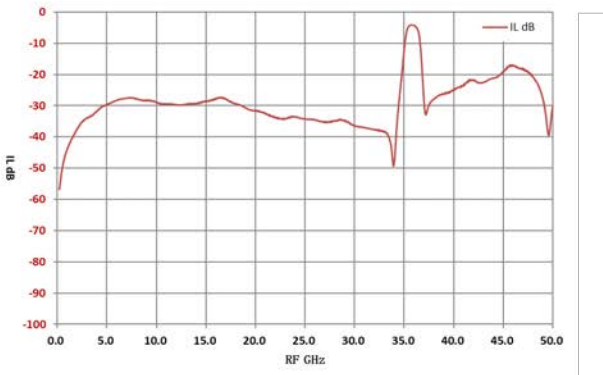
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

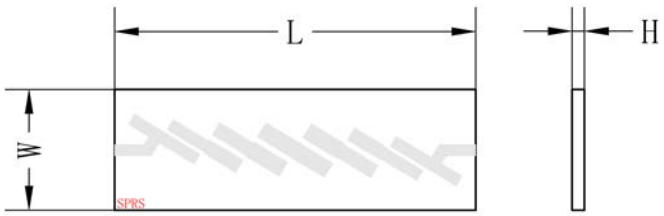
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	36.7	GHz
工作带宽	35.6-37.8	GHz
中心损耗	1.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.8:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-32.0GHz	dBc
带外抑制	40@42.0-46.0GHz	dBc

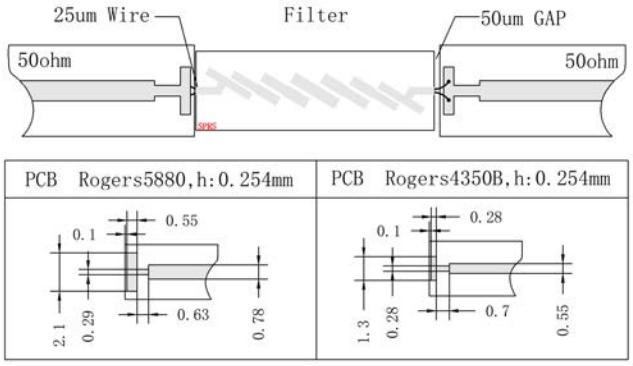
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

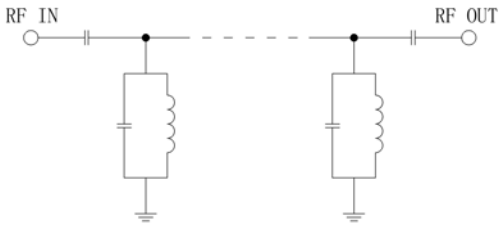
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

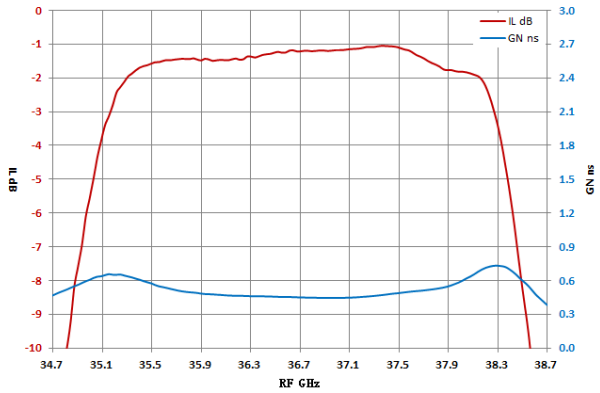
参考图

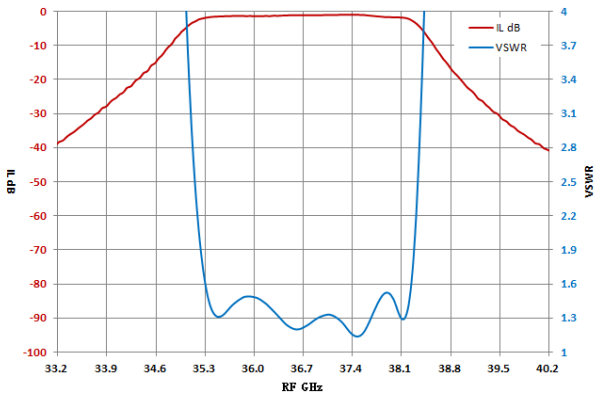


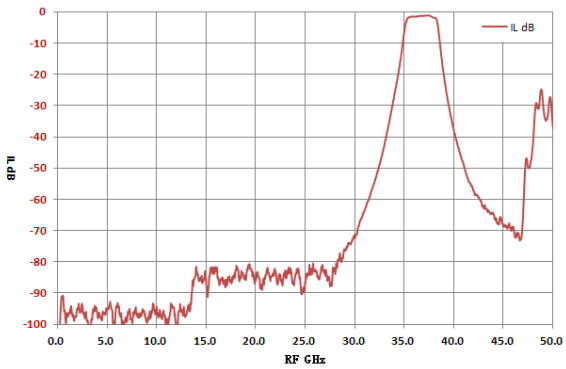
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

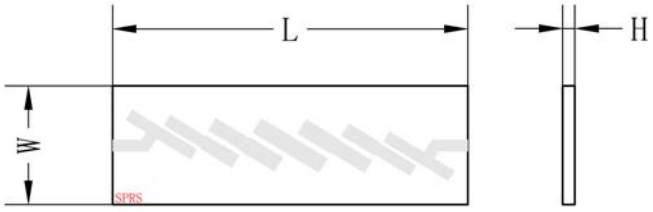
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	37.4	GHz
工作带宽	35.6-39.2	GHz
中心损耗	2.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-33.2GHz	dBc
带外抑制	40@42.8-48.0GHz	dBc

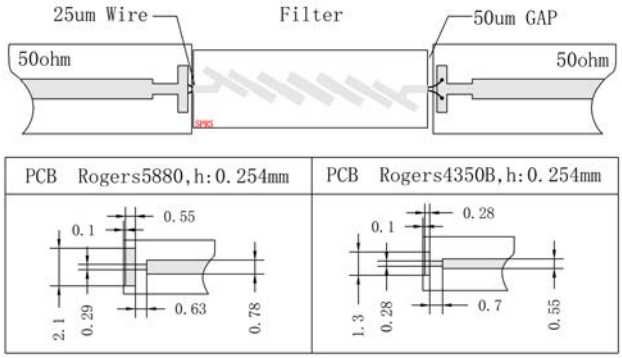
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



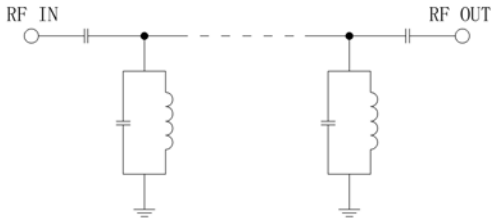
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

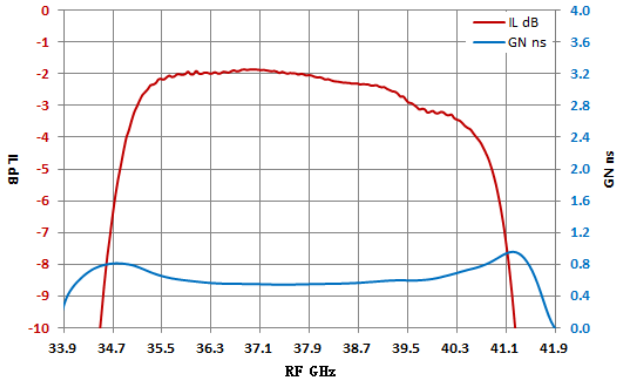
参考实物图

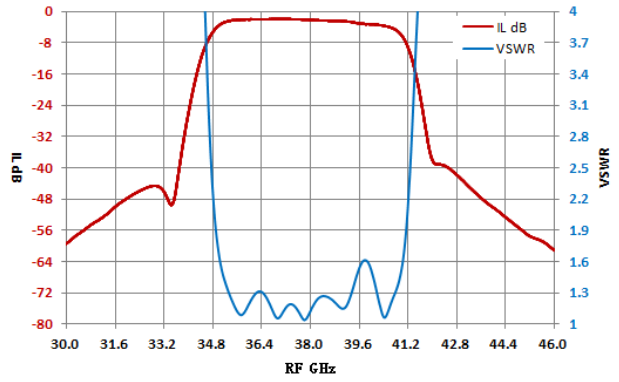


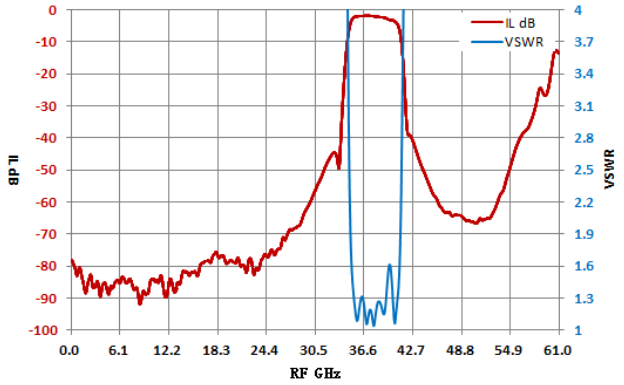
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



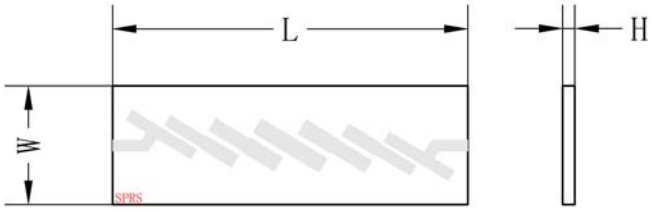
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	38.2	GHz
工作带宽	35.6-40.8	GHz
中心损耗	2.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-33.5GHz	dBc
带外抑制	40@43.6-49.0GHz	dBc

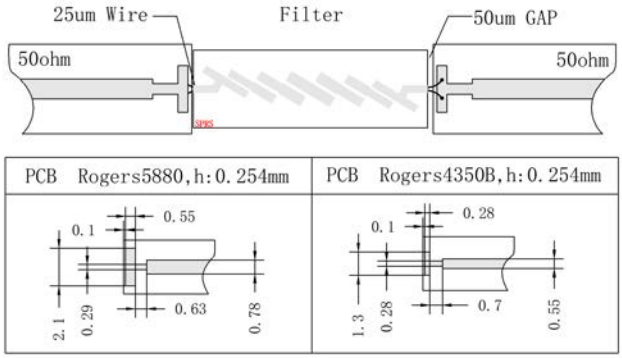
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



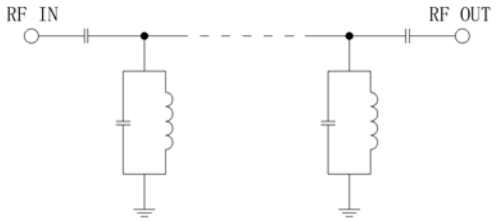
推荐装配图



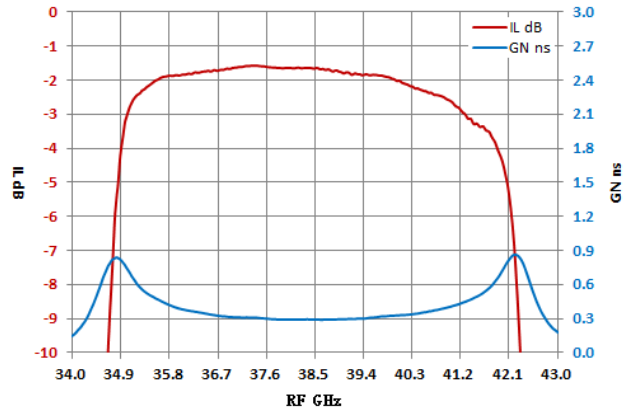
注意事项

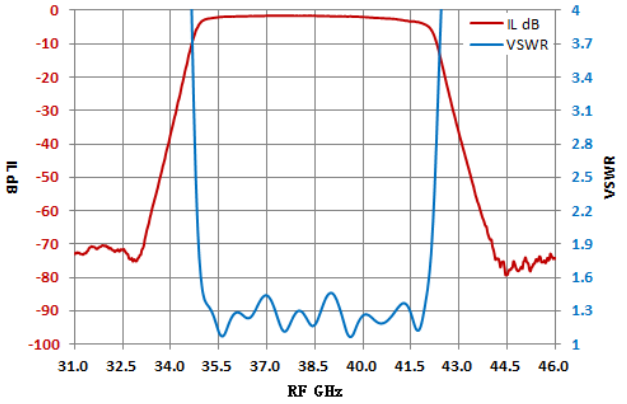
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.25mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

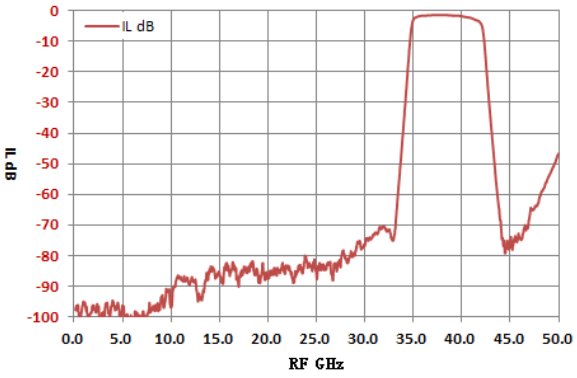
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



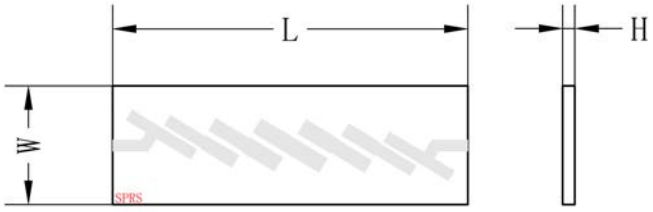
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	36.7	GHz
工作带宽	35.7-37.7	GHz
中心损耗	2.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@DC-33.6GHz	dBc
带外抑制	40@40.2-46.0GHz	dBc

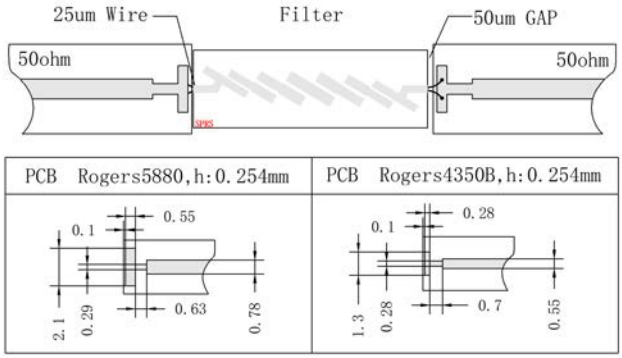
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：5.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



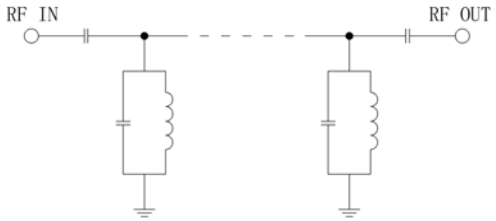
推荐装配图



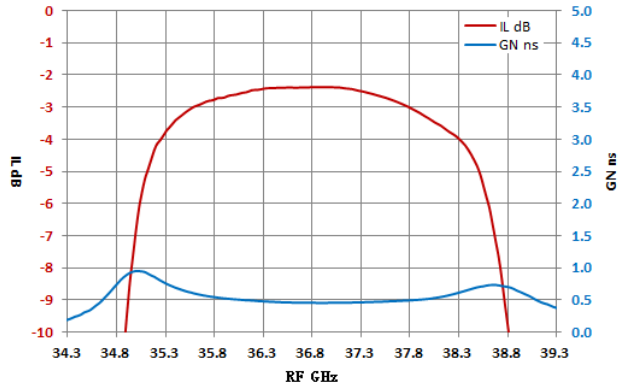
注意事项

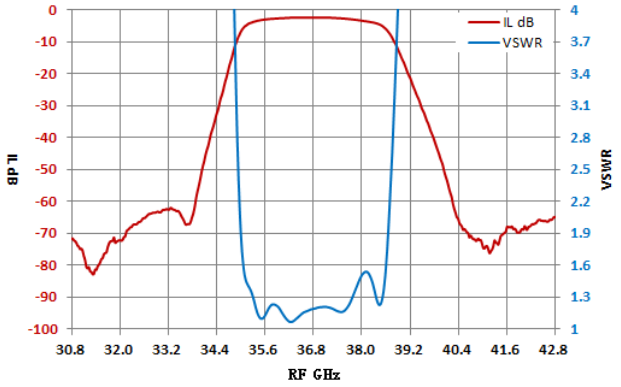
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

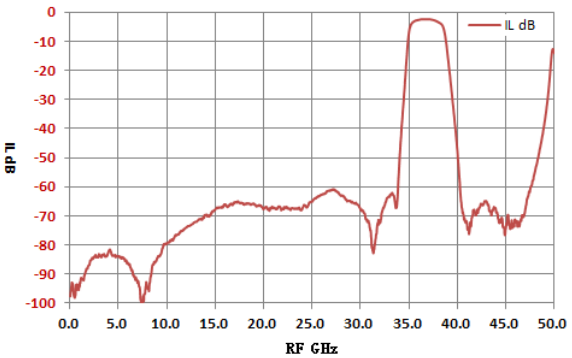
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

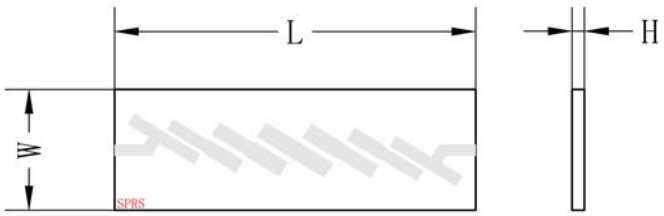
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	37.8	GHz
工作带宽	35.8-39.8	GHz
中心损耗	2.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	60@DC-33.4GHz	dBc
带外抑制	40@42.5-48.0GHz	dBc

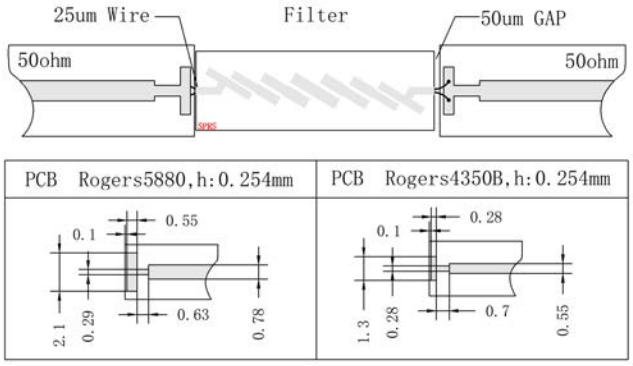
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：9.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

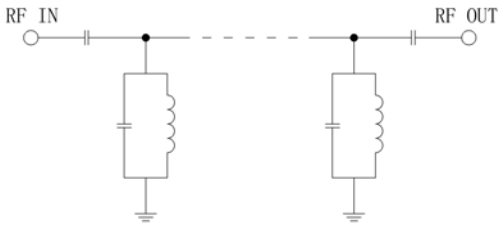
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

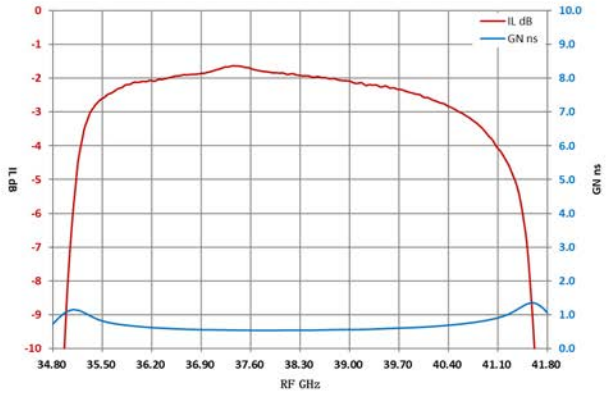
参考图

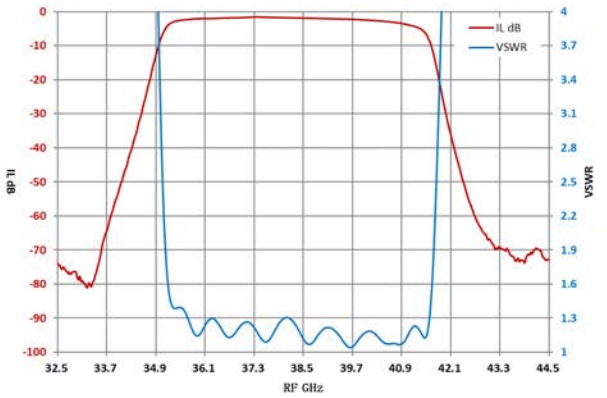


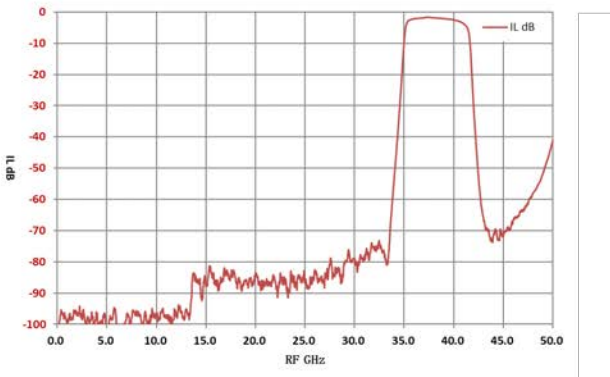
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

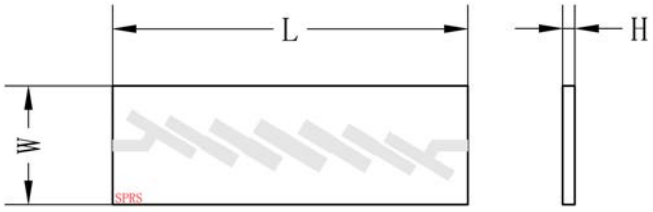
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	38.0	GHz
工作带宽	35.8-40.2	GHz
中心损耗	1.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-33.1GHz	dBc
带外抑制	40@43.0-45.0GHz	dBc

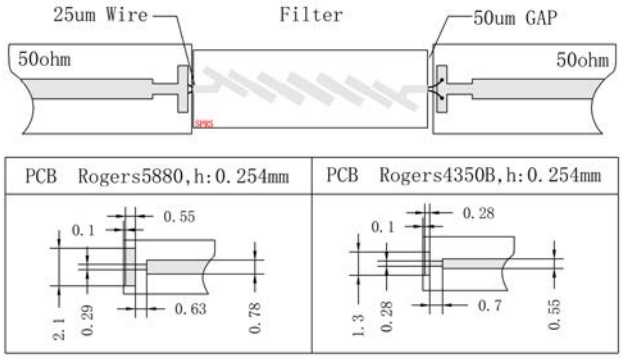
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



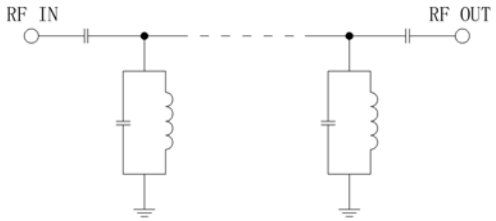
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

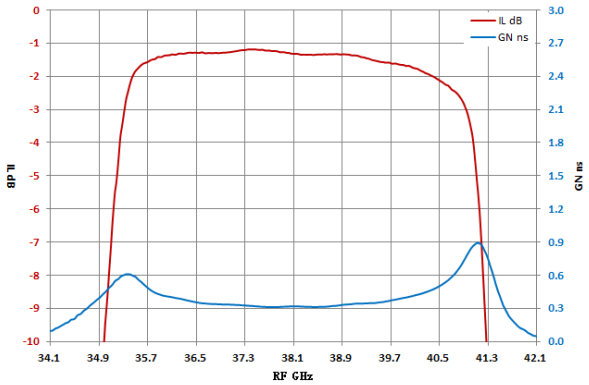
参考实物图

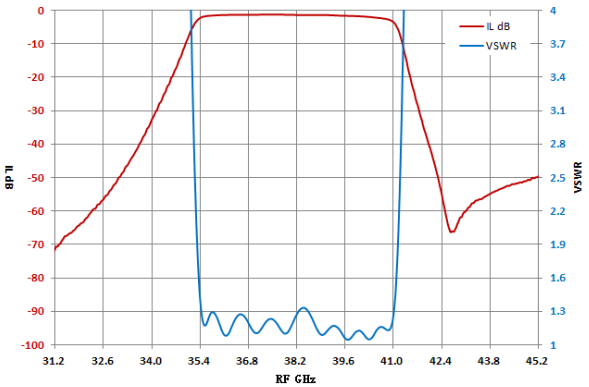


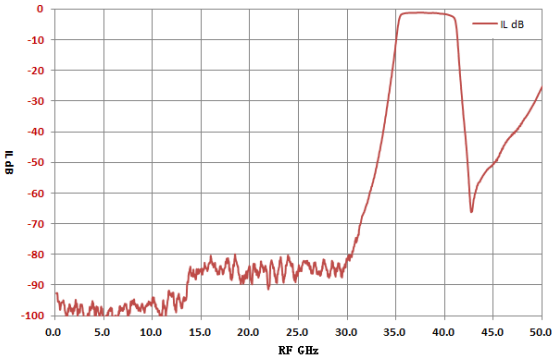
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



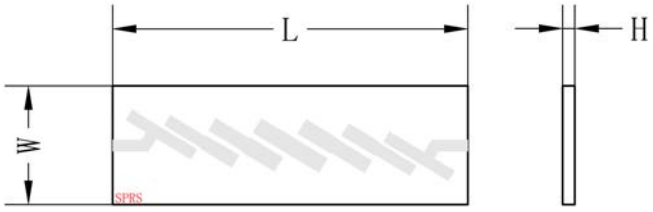
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	39.2	GHz
工作带宽	35.8-42.6	GHz
中心损耗	2.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-34.0GHz	dBc
带外抑制	40@45.7-48.5GHz	dBc

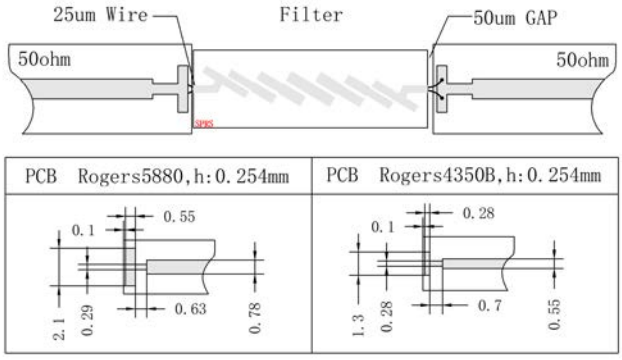
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



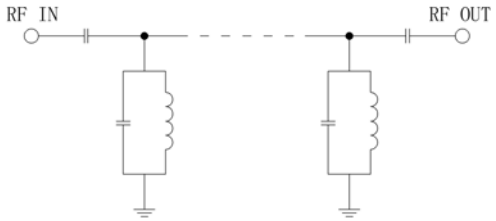
推荐装配图



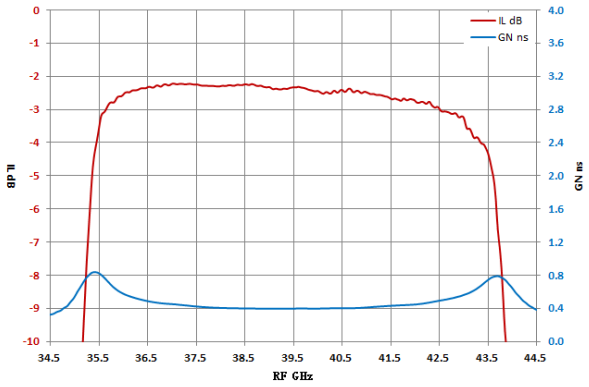
注意事项

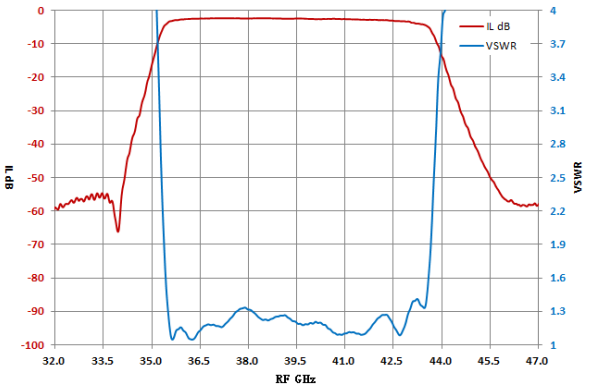
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

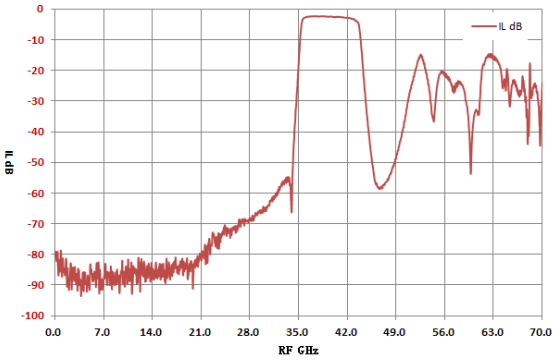
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



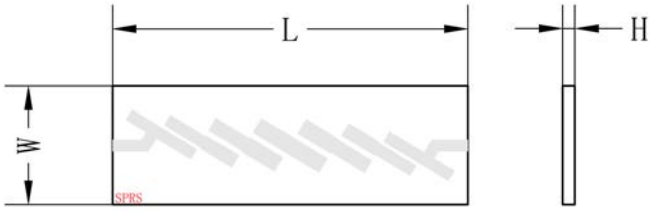
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	39.3	GHz
工作带宽	35.8-42.8	GHz
中心损耗	2.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-33.8GHz	dBc
带外抑制	40@46.5-50.0GHz	dBc

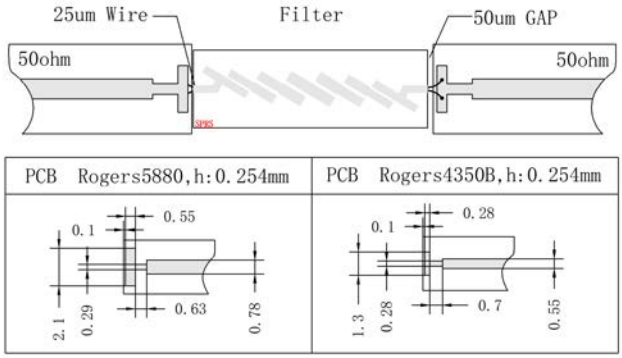
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



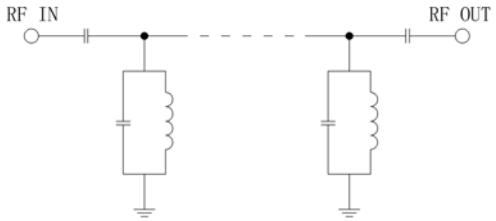
推荐装配图



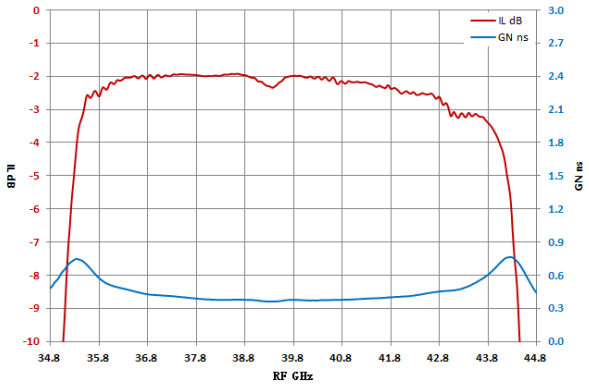
注意事项

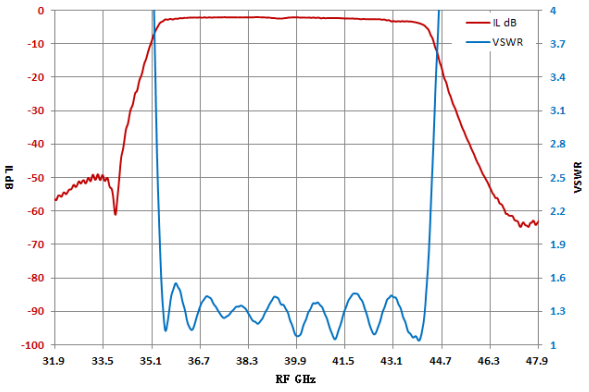
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

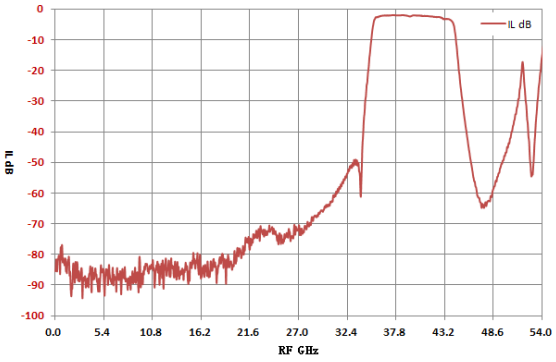
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



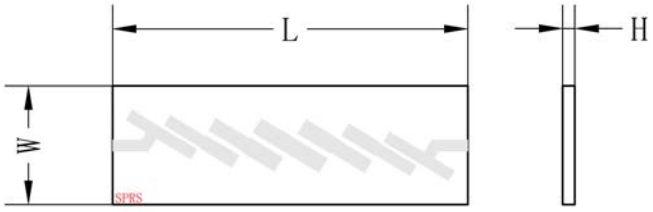
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	38.2	GHz
工作带宽	36.0-40.3	GHz
中心损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-34.2GHz	dBc
带外抑制	40@42.9-48.0GHz	dBc

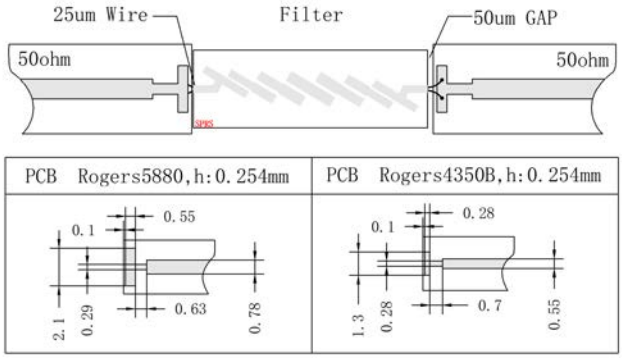
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.2，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



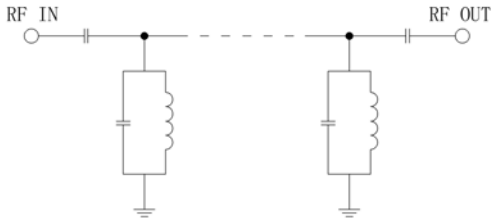
推荐装配图



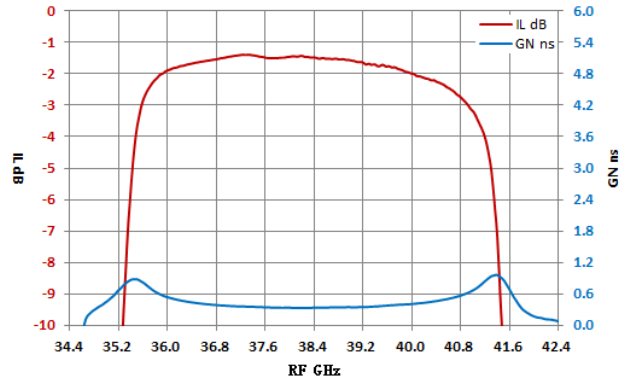
注意事项

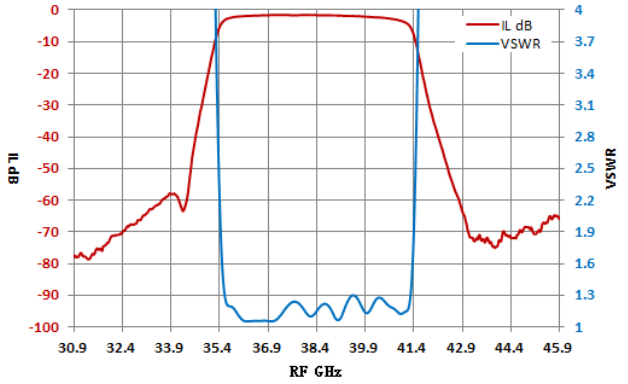
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

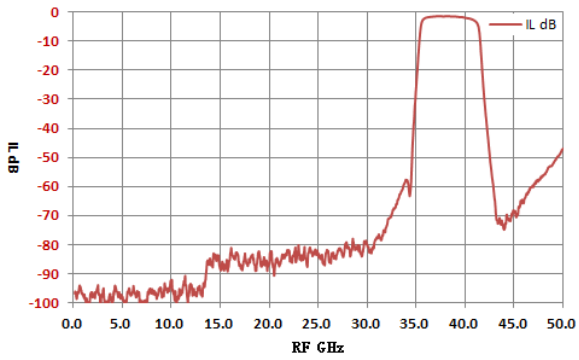
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

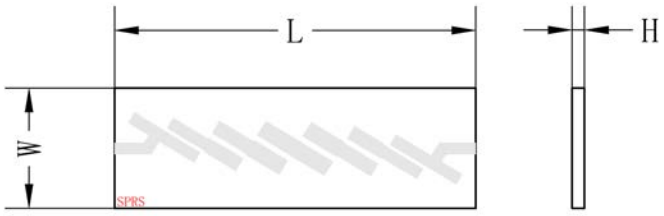
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	37.6	GHz
工作带宽	36.1-39.1	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.8:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	30@DC-34.2GHz	dBc
带外抑制	30@41.4-42.0GHz	dBc

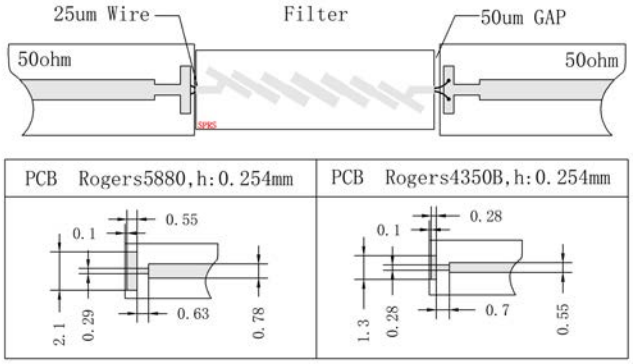
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：6.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

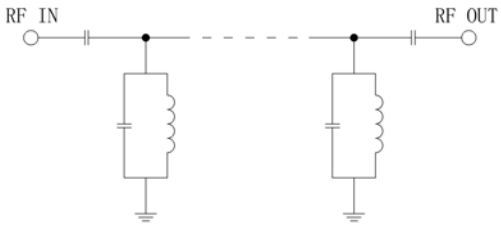
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

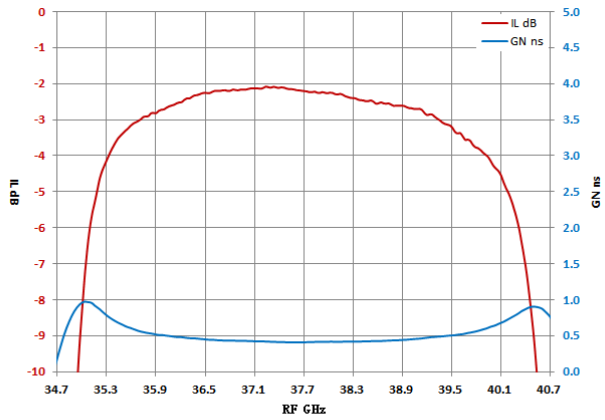
参考图

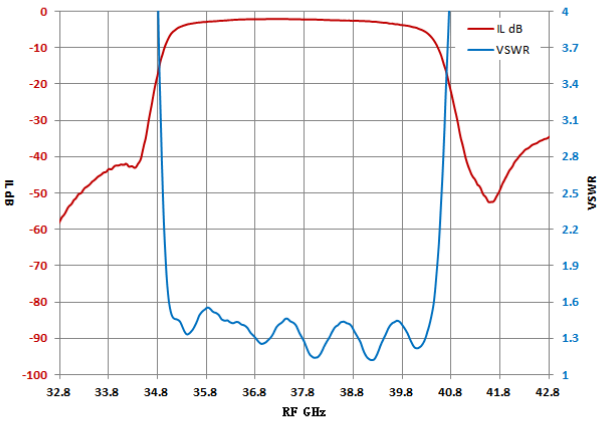


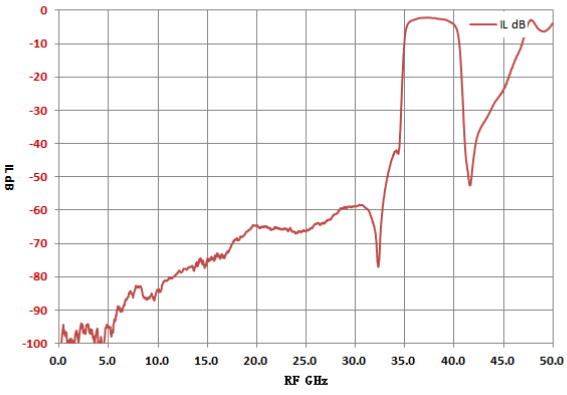
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

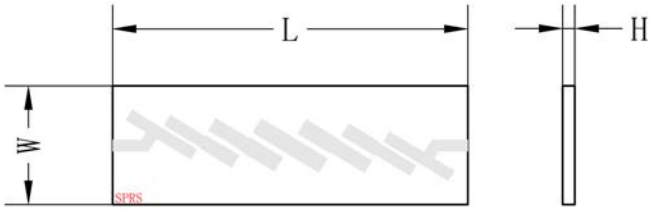
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	38.4	GHz
工作带宽	36.1-40.7	GHz
中心损耗	1.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-32.0GHz	dBc
带外抑制	40@44.4-58.0GHz	dBc

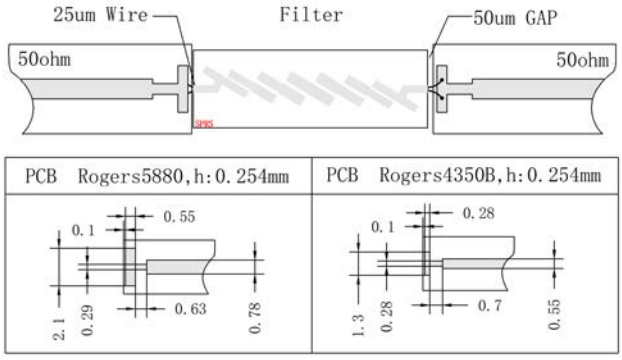
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



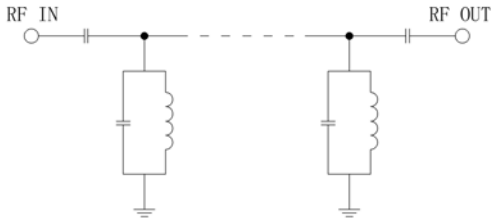
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.25mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

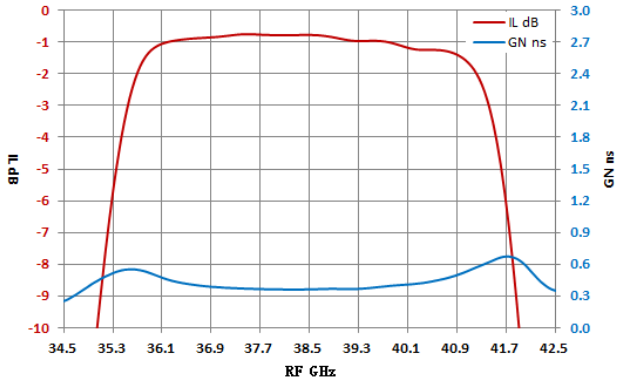
参考实物图

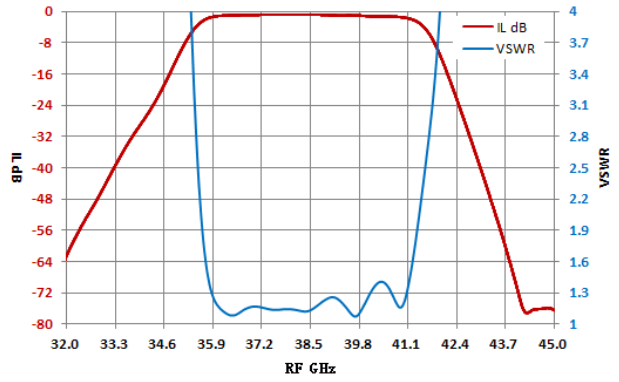


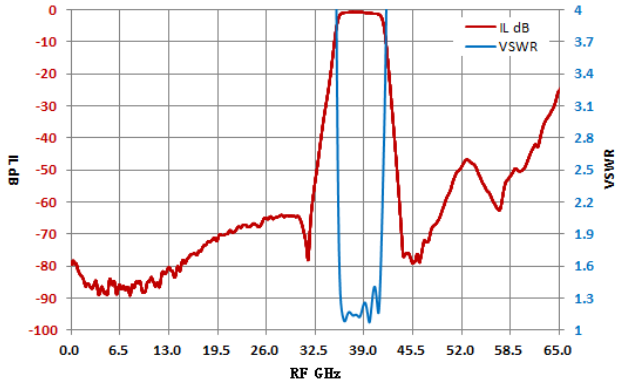
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

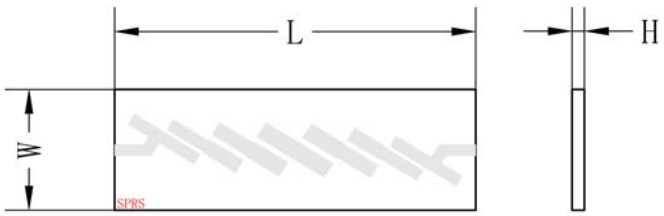
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	37.7	GHz
工作带宽	36.6-38.8	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.8:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-33.2GHz	dBc
带外抑制	40@42.2-47.0GHz	dBc

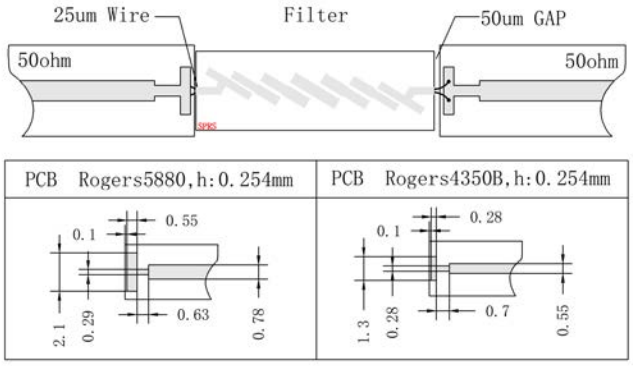
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

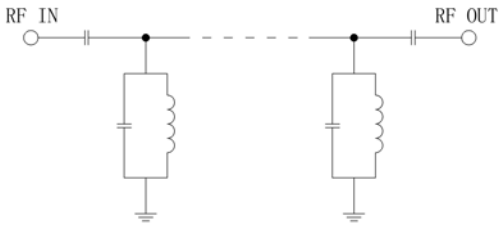
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

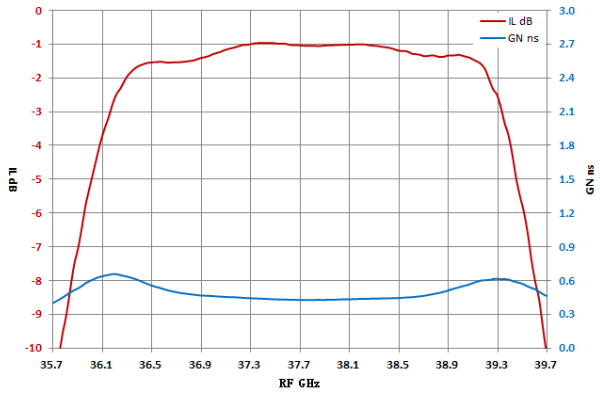
参考图

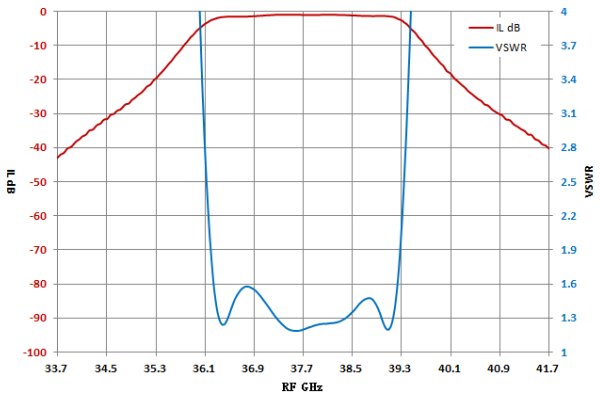


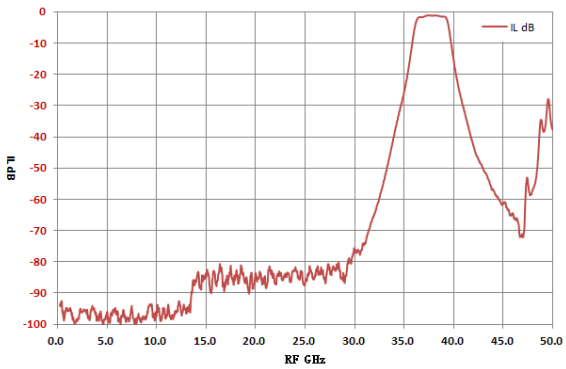
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



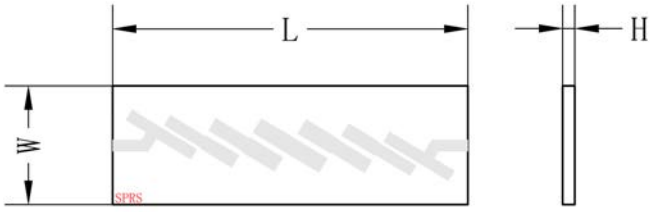
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	38.3	GHz
工作带宽	36.8-39.8	GHz
中心损耗	1.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-34.6GHz	dBc
带外抑制	37@42.5GHz	dBc

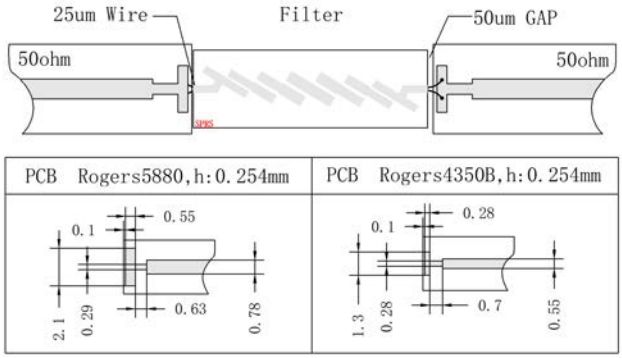
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



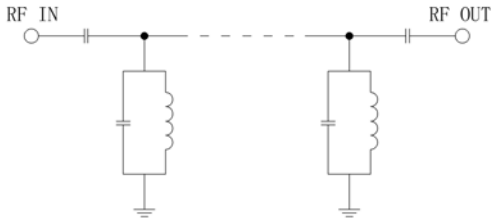
推荐装配图



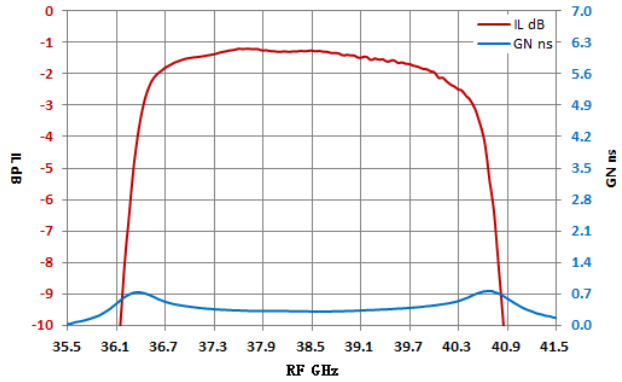
注意事项

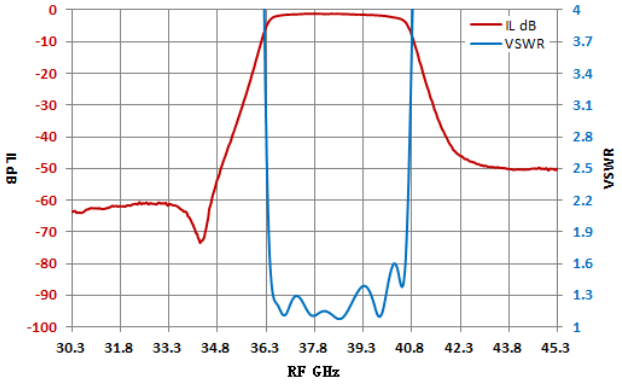
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

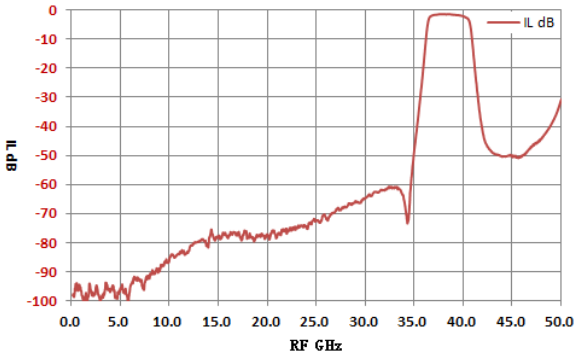
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

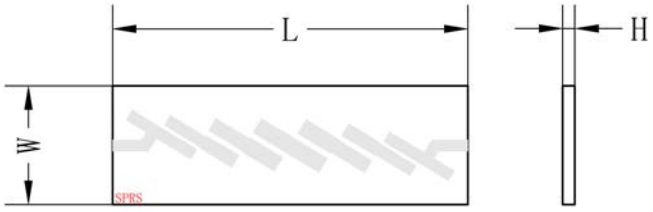
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	41.5	GHz
工作带宽	36.8-46.2	GHz
中心损耗	1.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-32.5GHz	dBc
带外抑制	40@52.4-59.0GHz	dBc

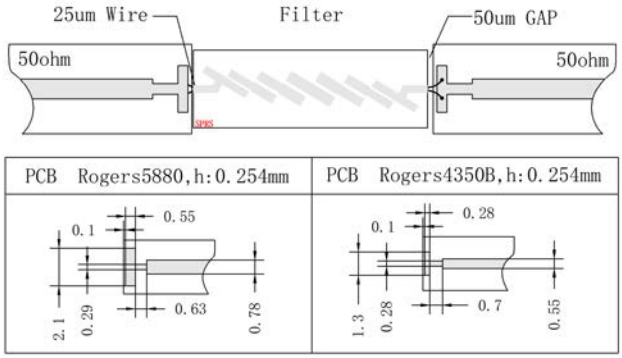
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



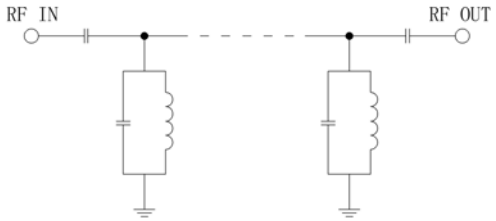
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

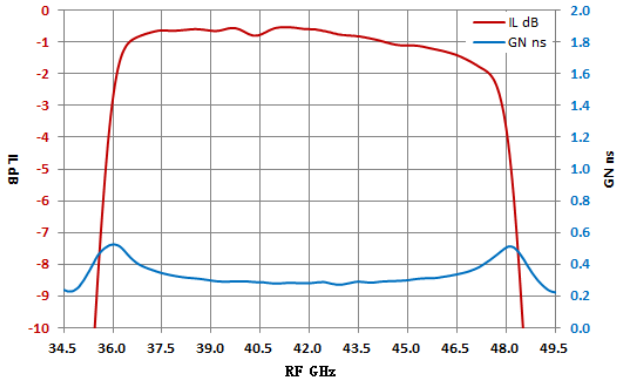
参考实物图

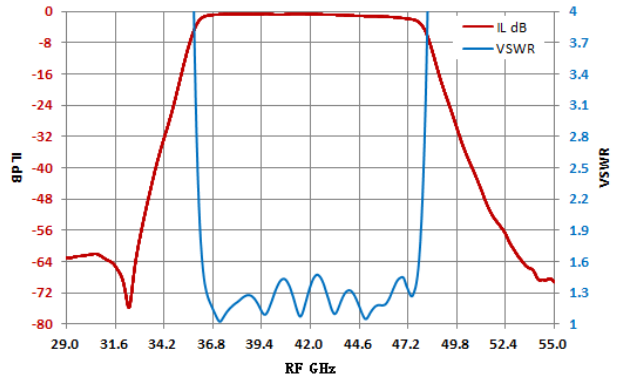


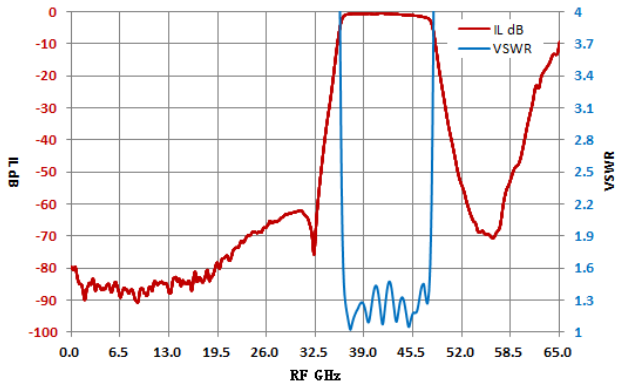
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

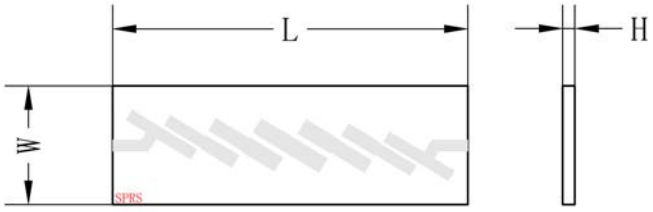
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	40.9	GHz
工作带宽	37.0-44.8	GHz
中心损耗	1.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-34.0GHz	dBc
带外抑制	40@48.8-53.0GHz	dBc

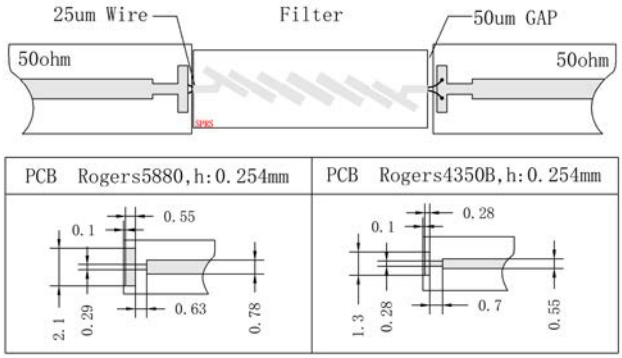
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：1.8，h：0.26

外形图：端口居中



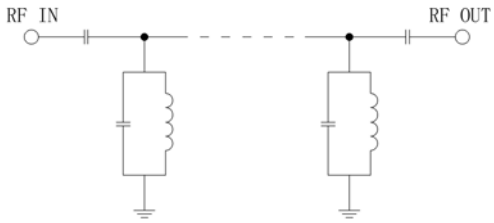
推荐装配图



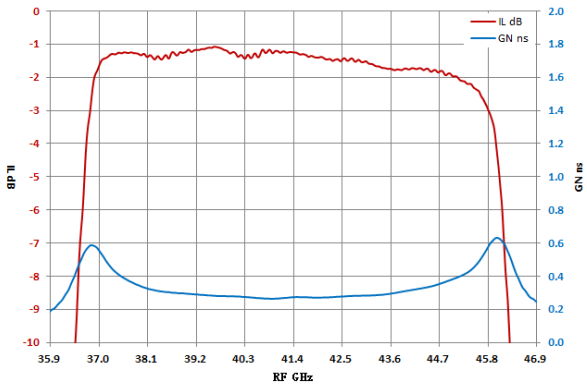
注意事项

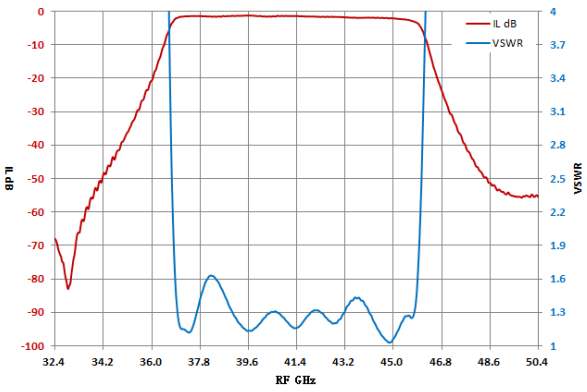
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

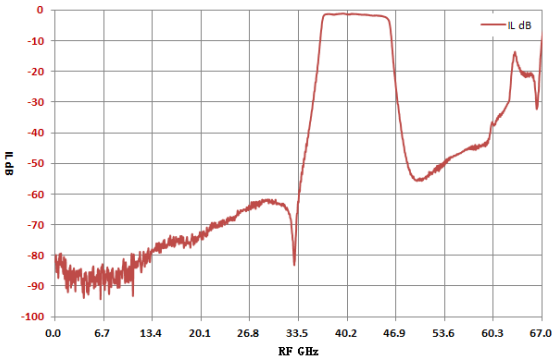
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

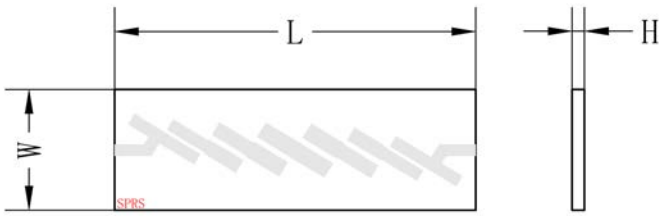
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	39.0	GHz
工作带宽	37.3-40.7	GHz
中心损耗	2.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-35.0GHz	dBc
带外抑制	40@42.9-56.0GHz	dBc

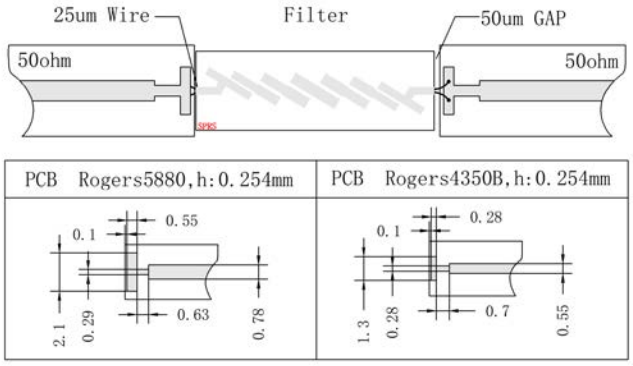
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：7.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

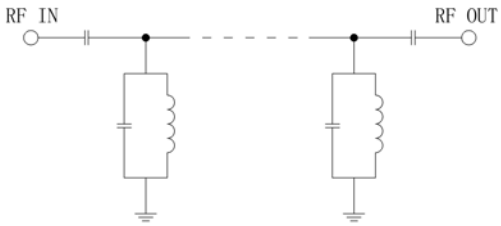
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

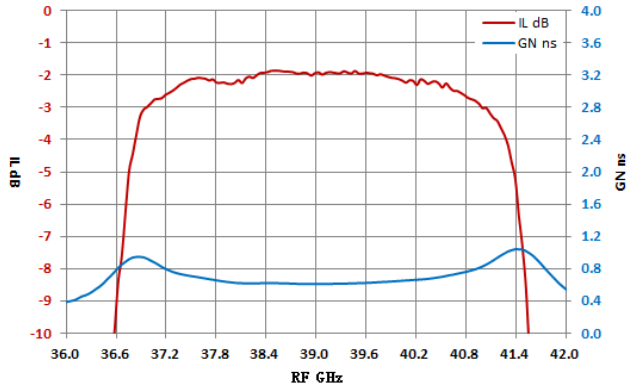
参考图

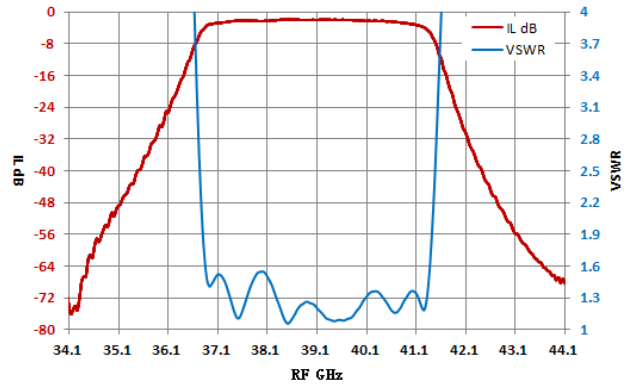


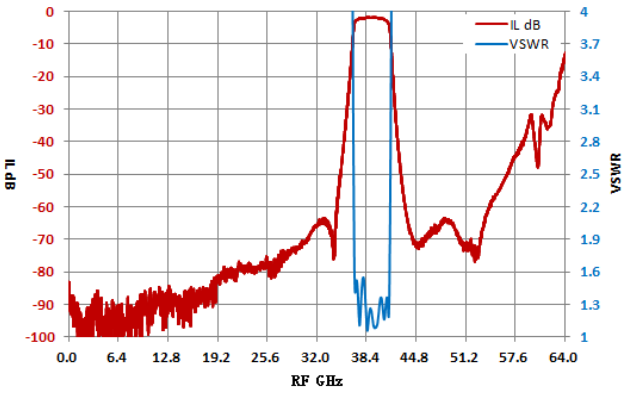
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

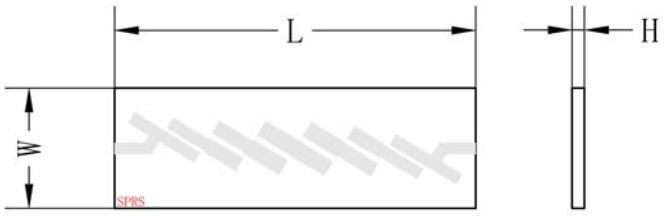
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	40.2	GHz
工作带宽	37.4-43.0	GHz
中心损耗	2.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-34.5GHz	dBc
带外抑制	30@45.8-60.0GHz	dBc

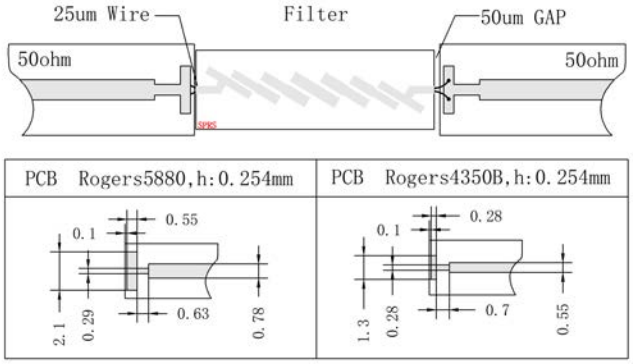
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：5.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

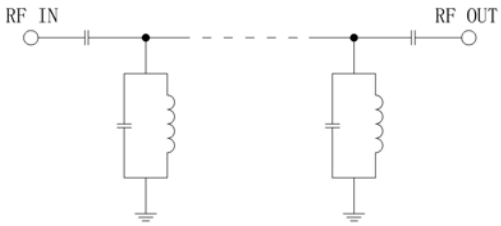
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

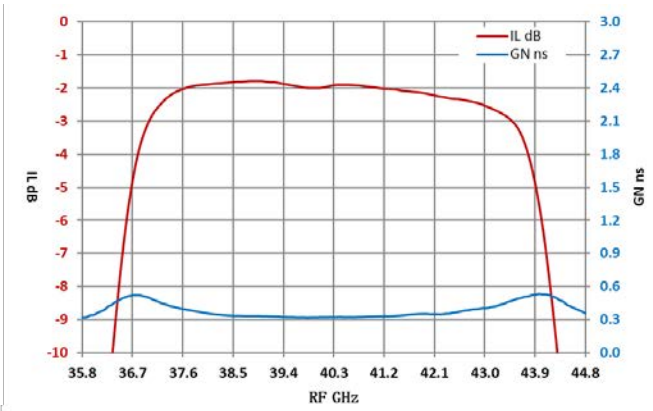
参考图

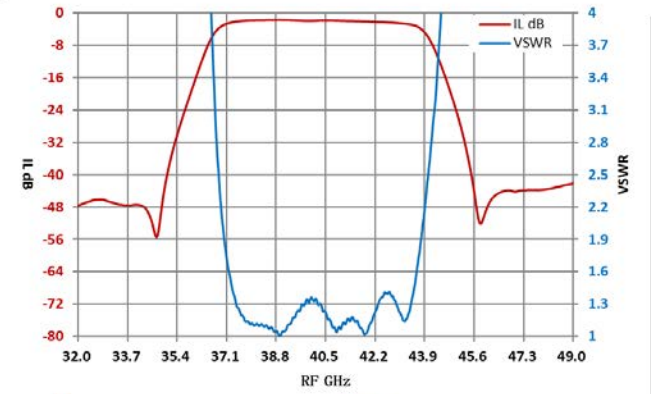


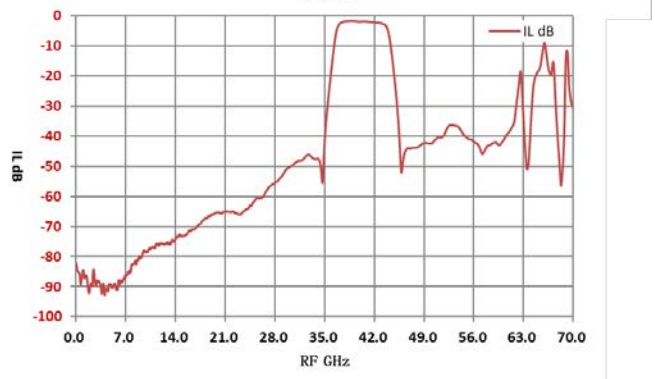
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

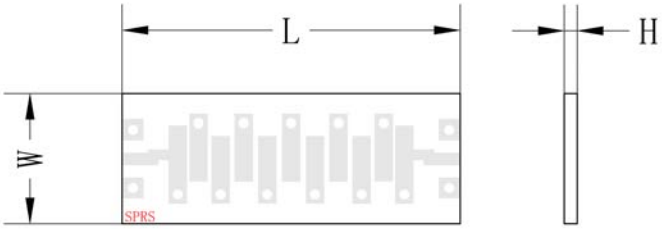
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	38.75	GHz
工作带宽	37.5-40.0	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-34.0GHz	dBc
带外抑制	40@43.4-50.0GHz	dBc

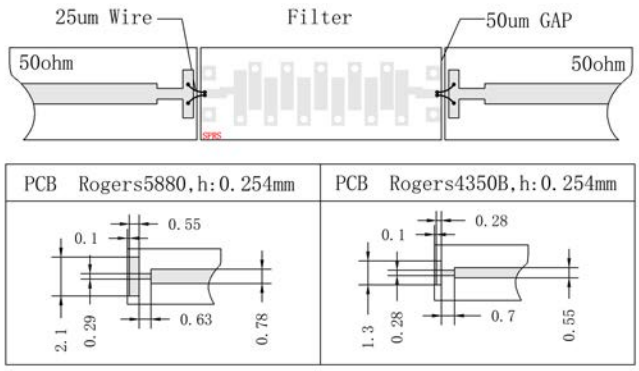
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：7.5，W：2.4，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

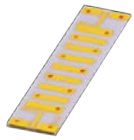
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

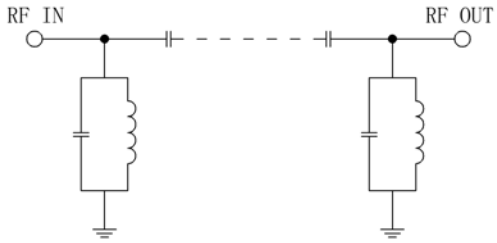
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

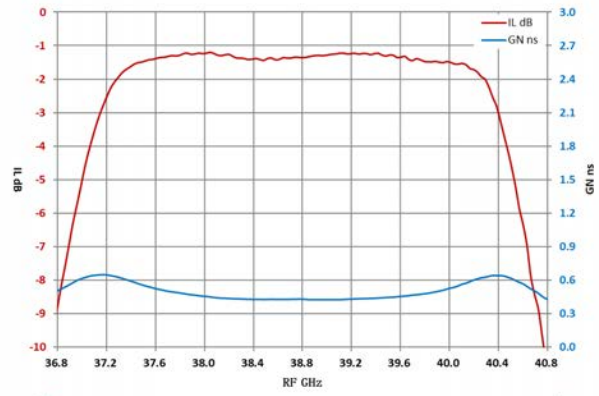
参考图

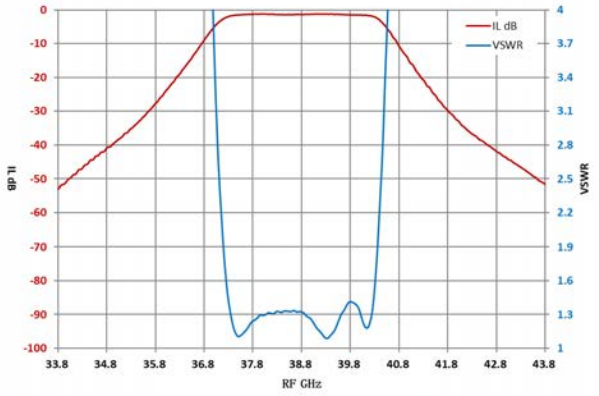


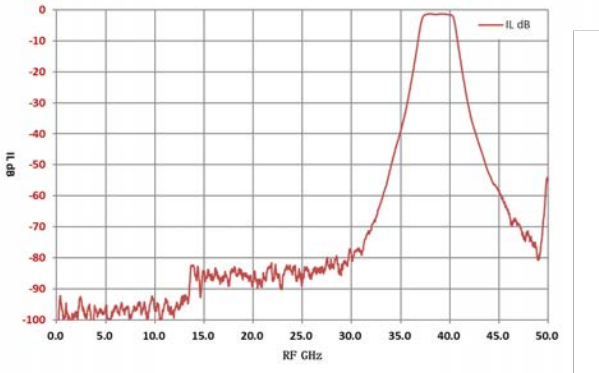
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

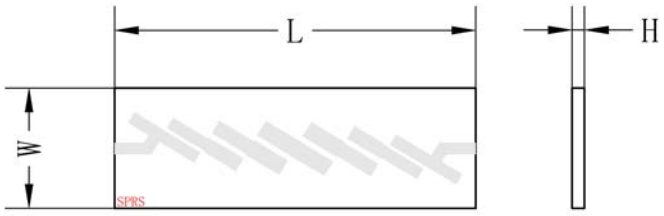
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	39.4	GHz
工作带宽	37.5-41.3	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-35.0GHz	dBc
带外抑制	35@44.2-60.0GHz	dBc

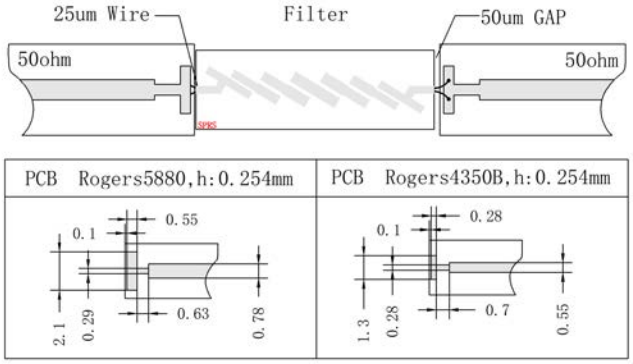
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：6.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

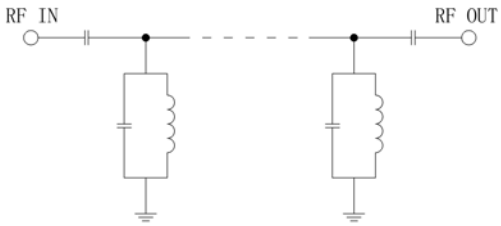
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

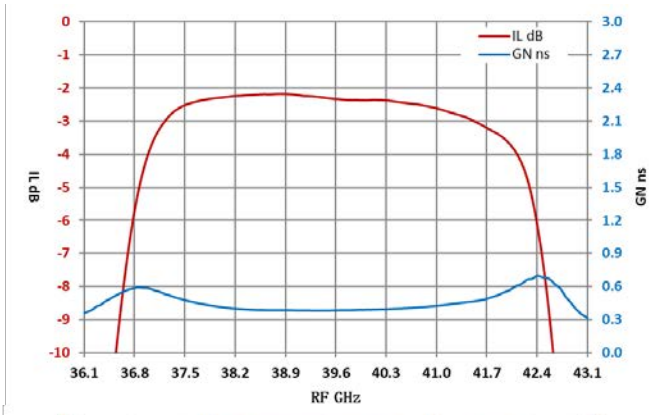
参考图

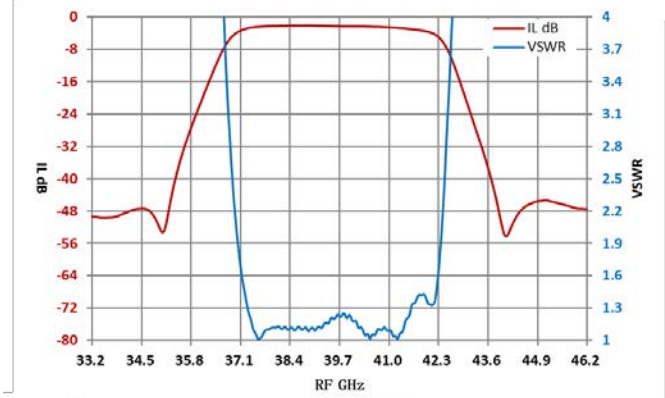


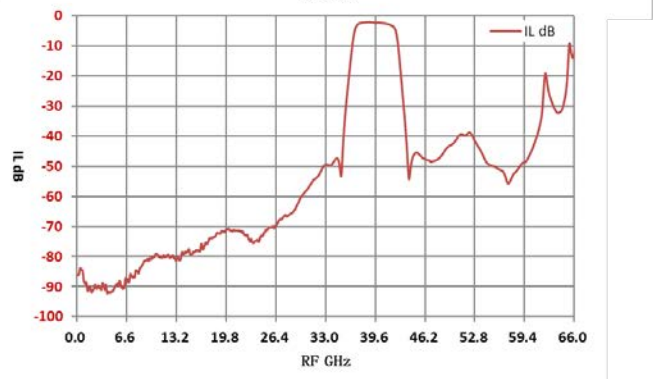
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

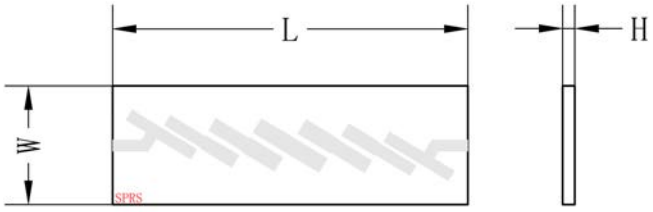
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	39.1	GHz
工作带宽	38.0-40.2	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-35.9GHz	dBc
带外抑制	40@42.3-46.0GHz	dBc

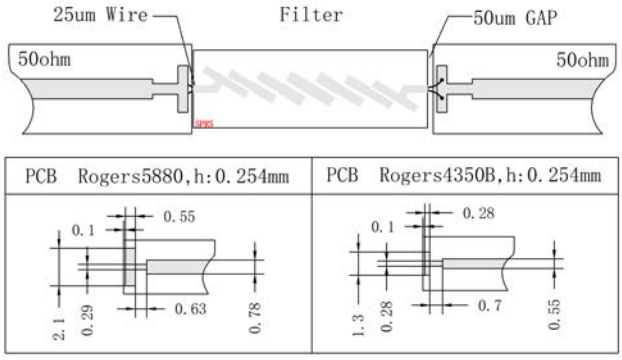
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



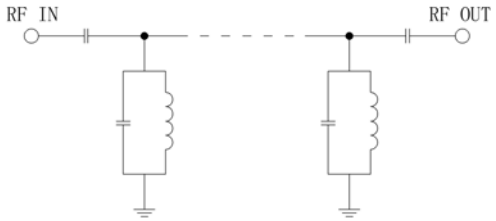
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

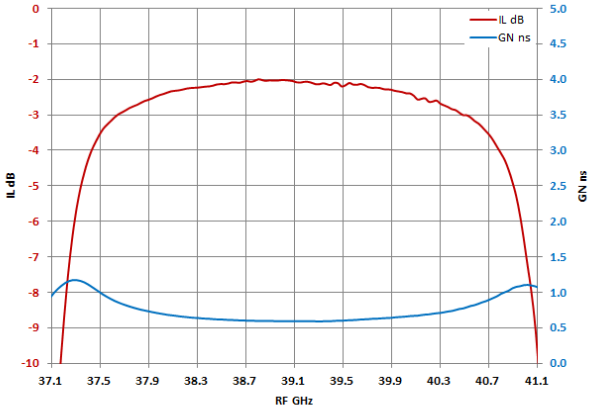
参考实物图

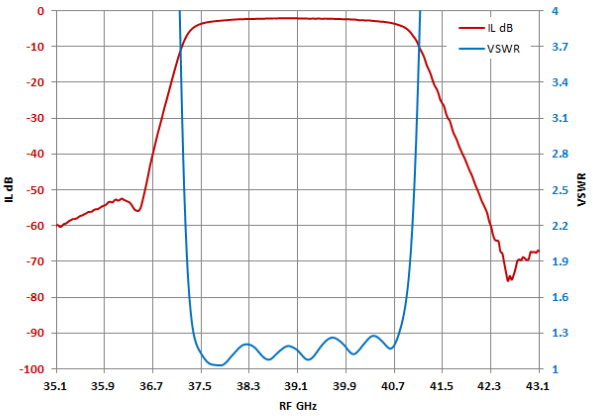


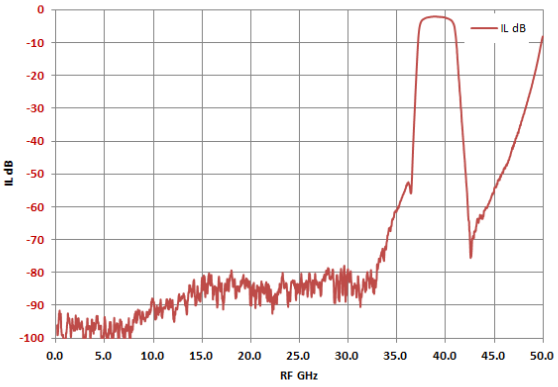
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



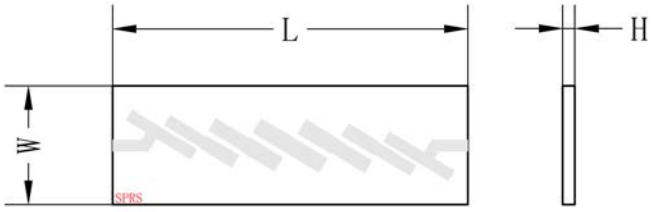
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	39.1	GHz
工作带宽	38.1-40.1	GHz
中心损耗	3.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	15@DC-36.7GHz	dBc
带外抑制	10@43.0-44.0GHz	dBc

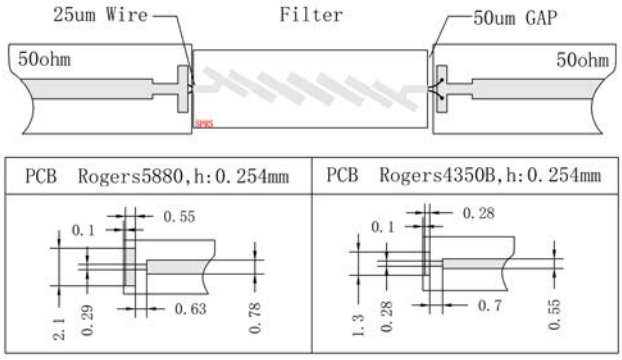
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



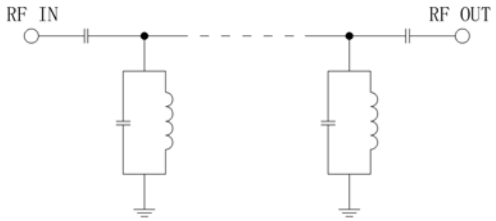
推荐装配图



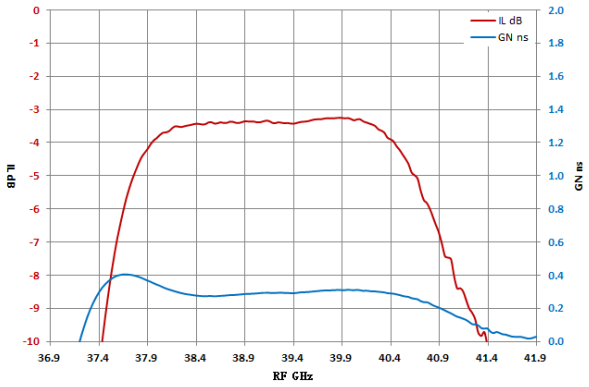
注意事项

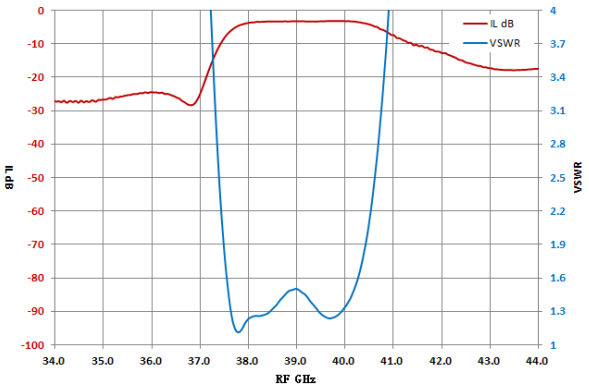
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

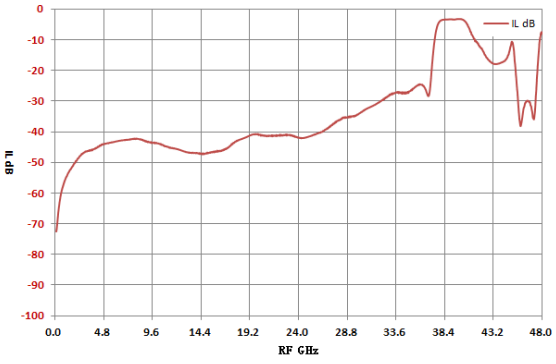
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



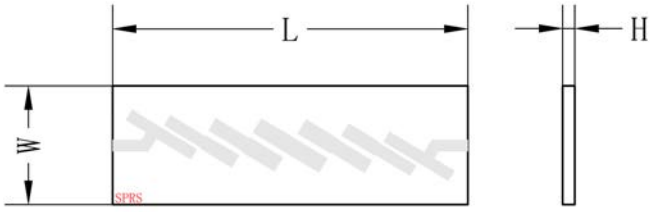
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	44.7	GHz
工作带宽	38.4-51.0	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-34.2GHz	dBc
带外抑制	40@56.2-57.0GHz	dBc

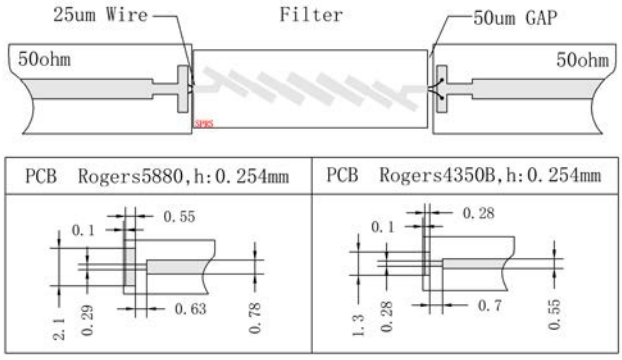
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：5.5，W：1.8，h：0.26

外形图：端口居中



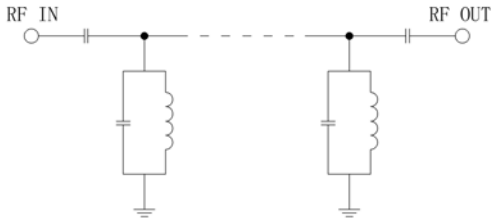
推荐装配图



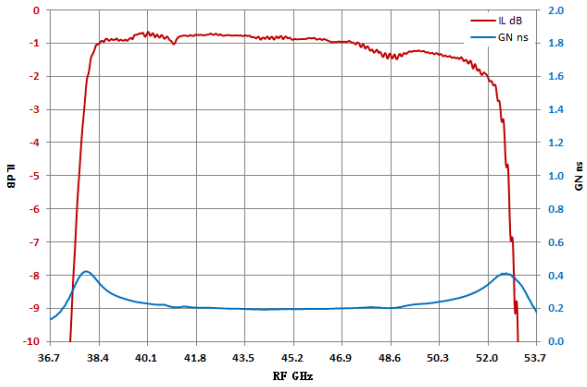
注意事项

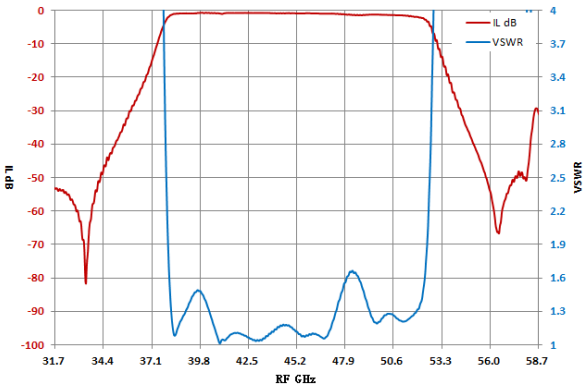
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

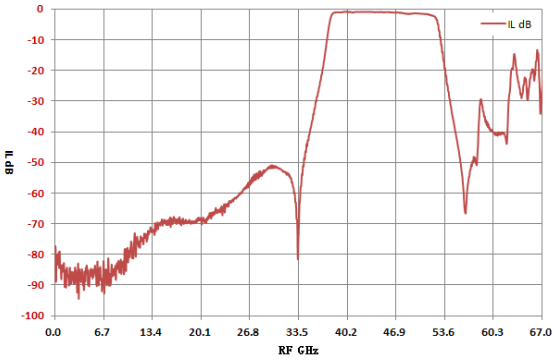
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

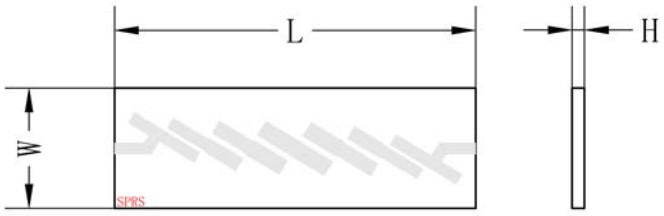
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	41.8	GHz
工作带宽	38.6-45.0	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-36.4GHz	dBc
带外抑制	40@48.5-55.0GHz	dBc

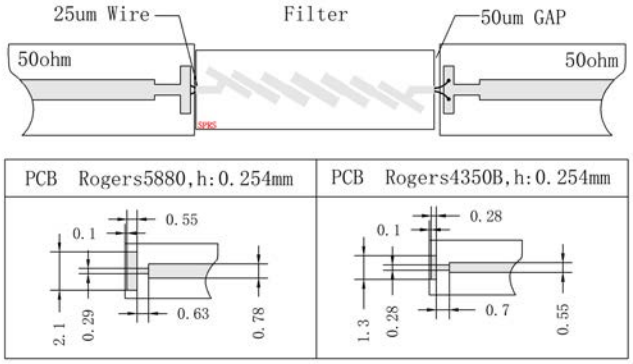
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

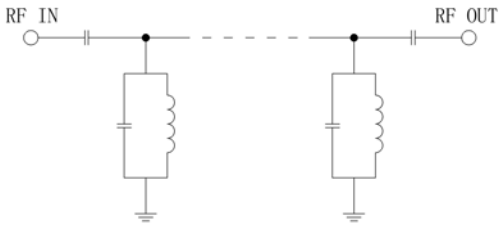
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

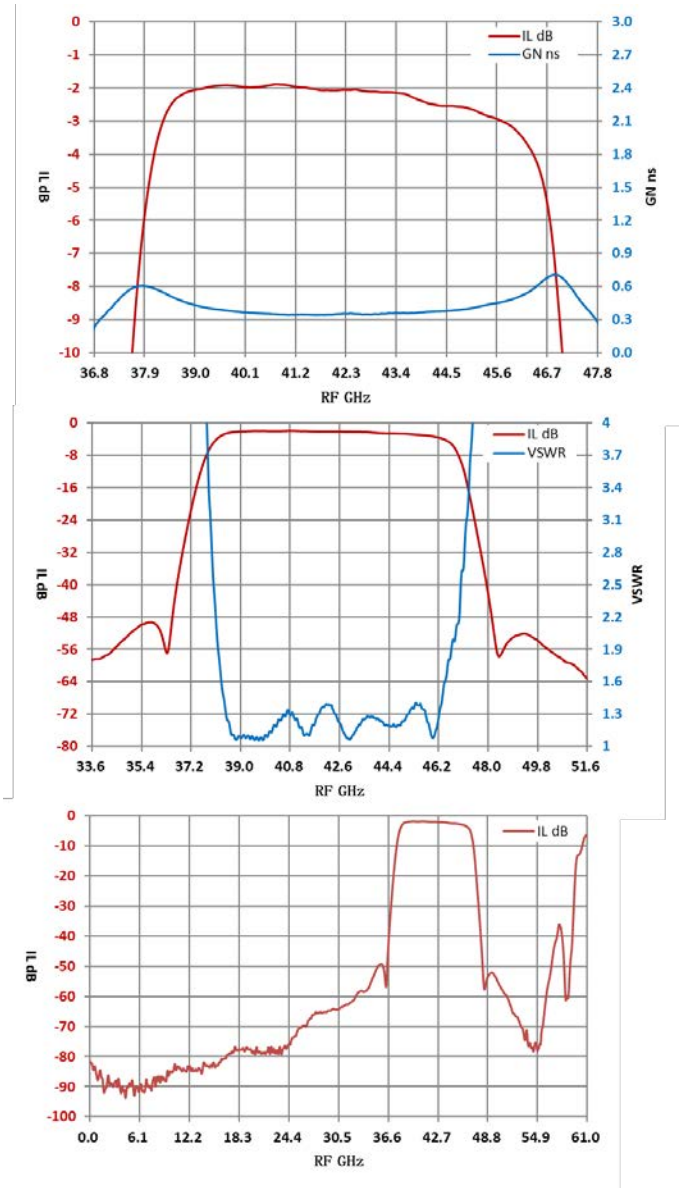
参考图



原理图



典型曲线



产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

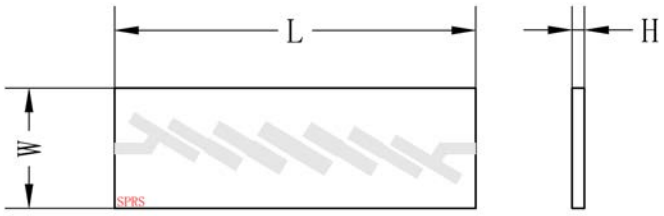
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	43.9	GHz
工作带宽	38.6-49.2	GHz
中心损耗	2.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-33.0GHz	dBc
带外抑制	30@55.0-70.0GHz	dBc

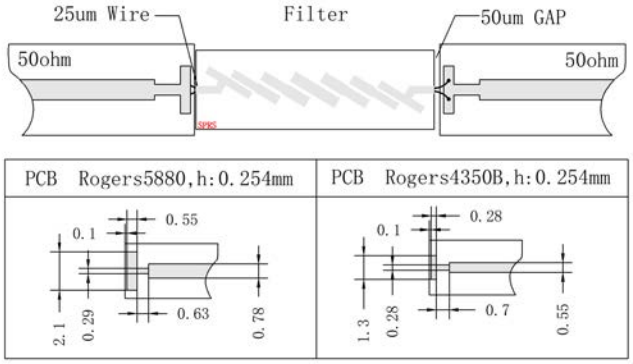
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：5.5，W：1.6，h：0.13

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.87mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

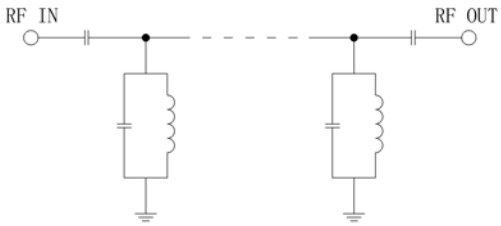
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

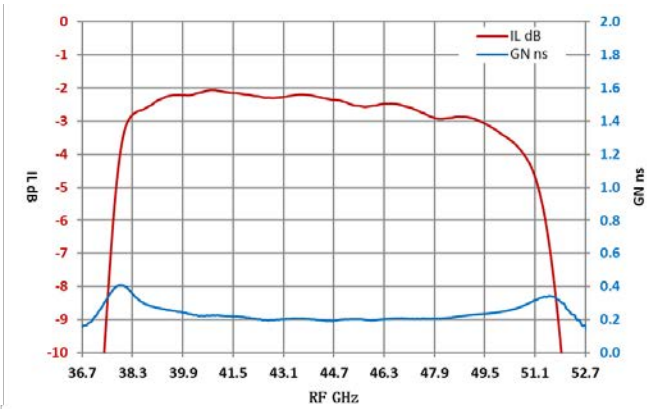
参考图

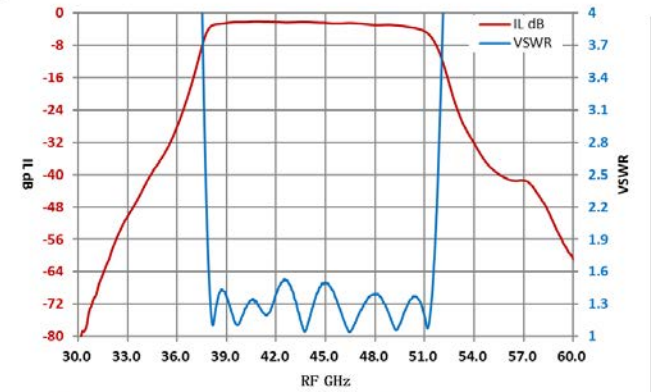


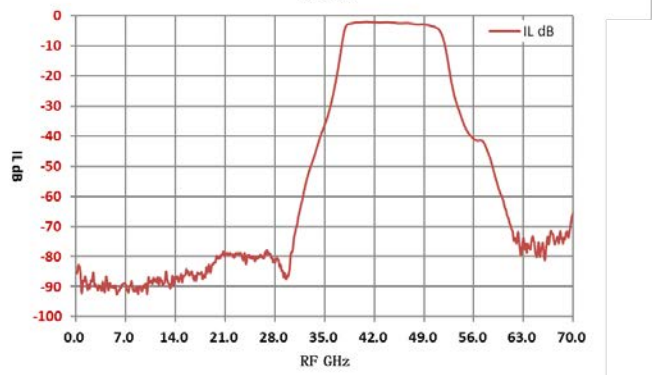
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

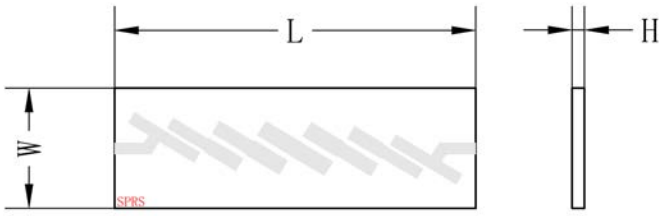
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	41.0	GHz
工作带宽	38.7-43.3	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-36.2GHz	dBc
带外抑制	40@46.0-52.0GHz	dBc

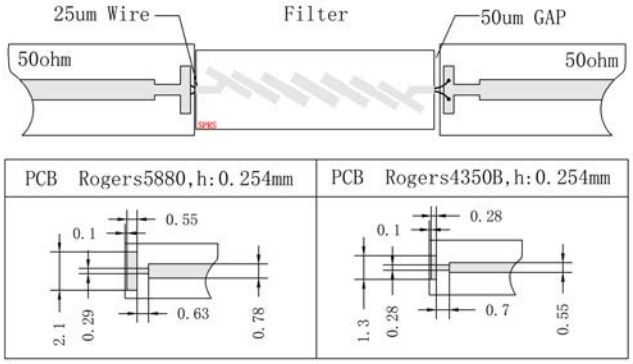
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

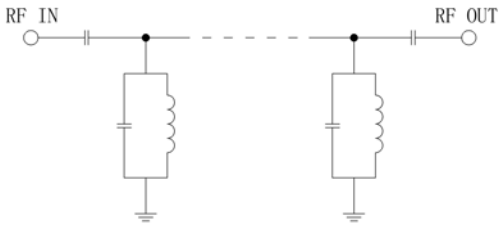
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

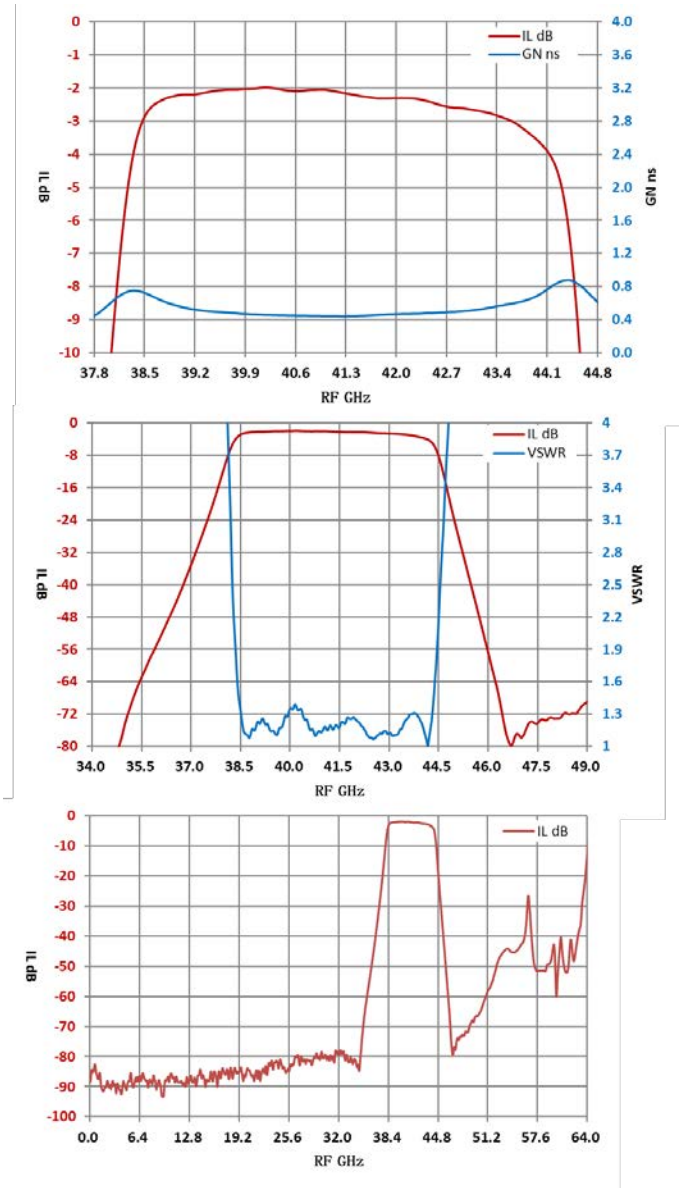
参考图



原理图



典型曲线



产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

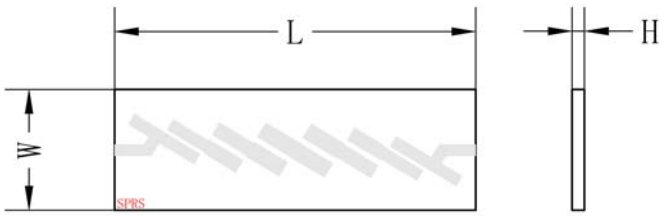
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	39.6	GHz
工作带宽	38.8-40.4	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-37.1GHz	dBc
带外抑制	40@42.4-50.0GHz	dBc

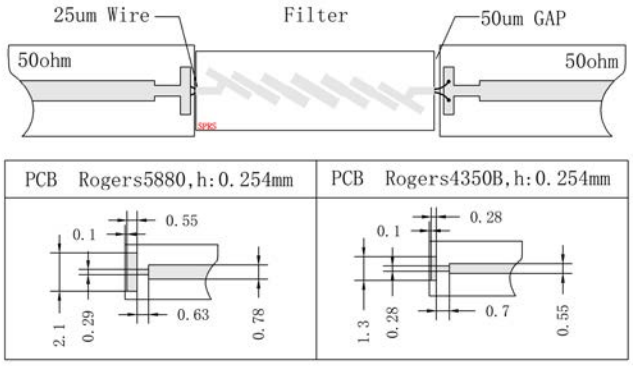
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：6.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

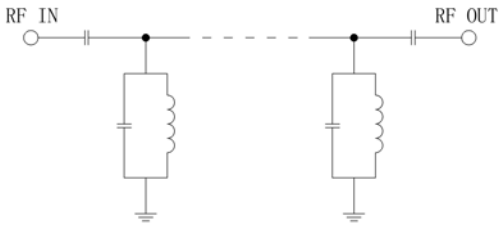
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

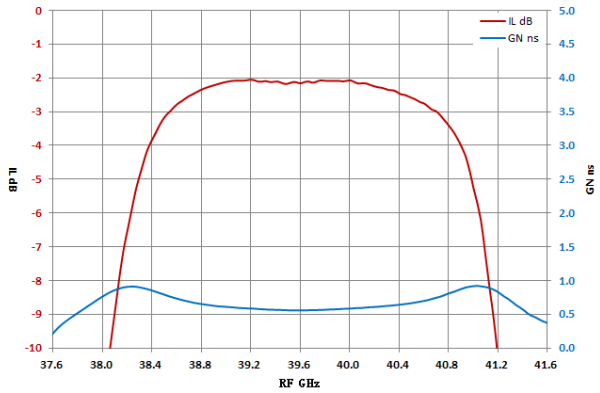
参考图

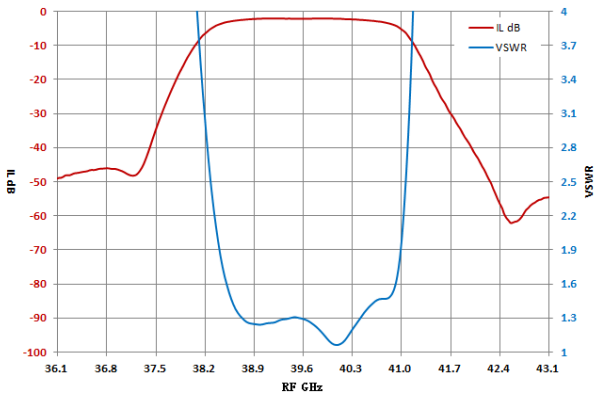


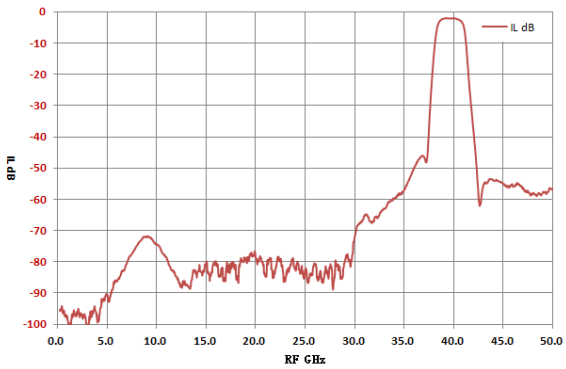
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



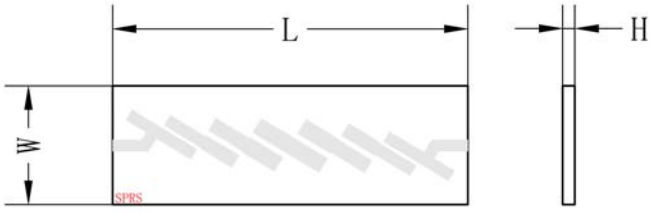
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	39.8	GHz
工作带宽	38.8-40.8	GHz
中心损耗	2.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-34.0GHz	dBc
带外抑制	40@43.6-54.0GHz	dBc

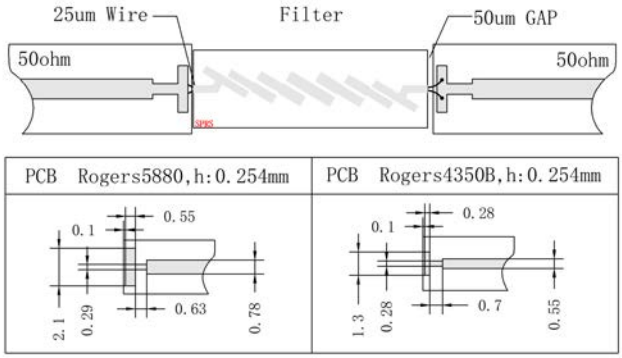
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：5.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



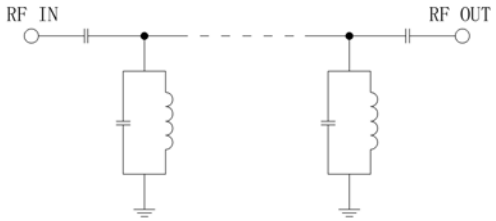
推荐装配图



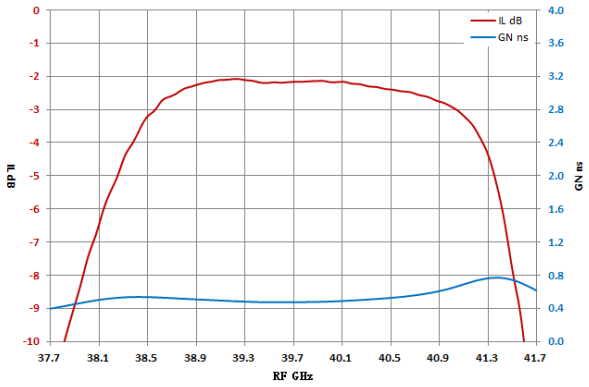
注意事项

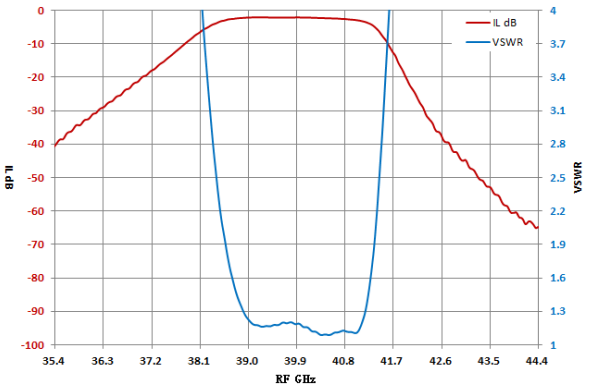
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

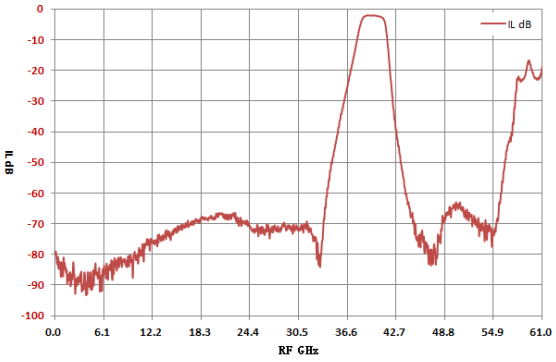
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

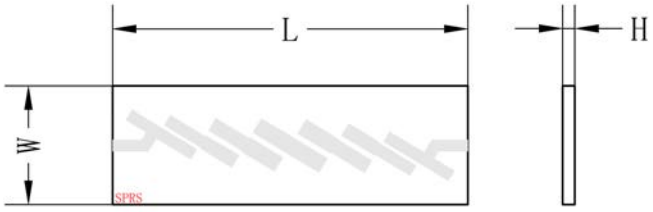
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	42.4	GHz
工作带宽	38.8-46.0	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-34.6GHz	dBc
带外抑制	40@51.4-59.0GHz	dBc

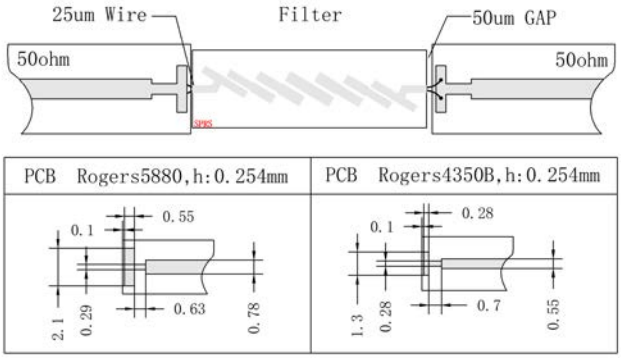
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：1.8，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



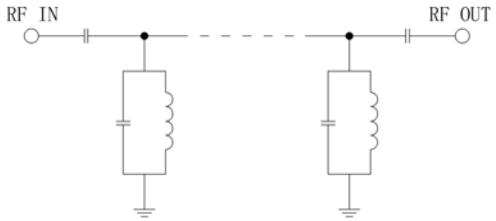
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

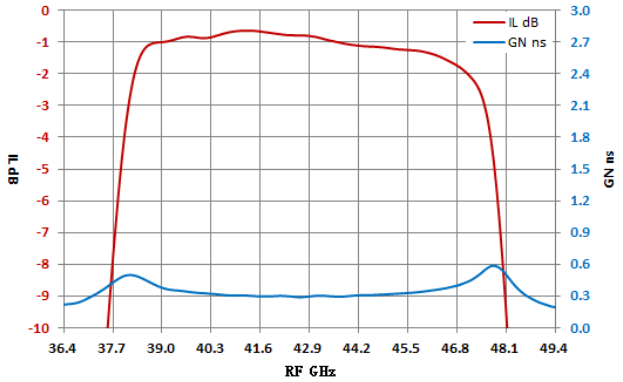
参考实物图

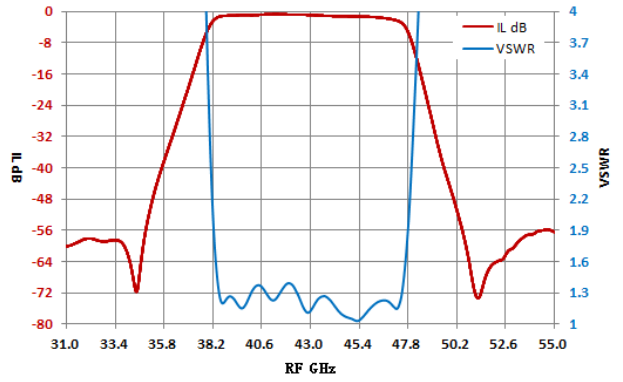


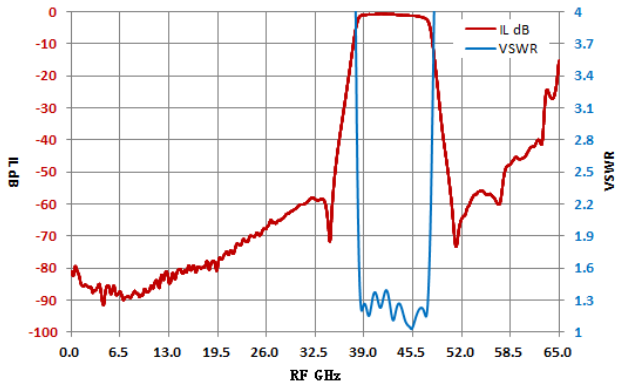
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



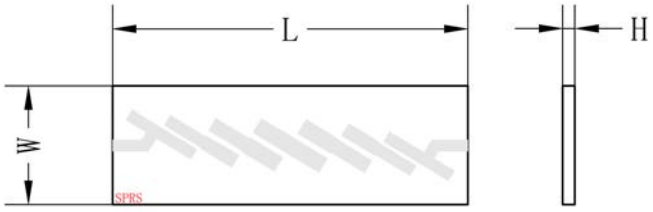
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	44.5	GHz
工作带宽	39.0-50.0	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-33.5GHz	dBc
带外抑制	35@55.5-60.0GHz	dBc

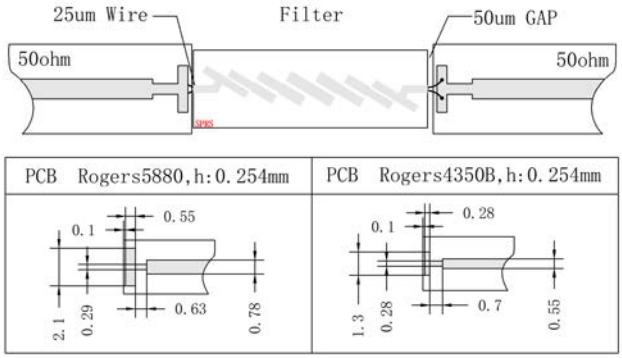
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：5.0，W：1.8，h：0.26

外形图：端口居中



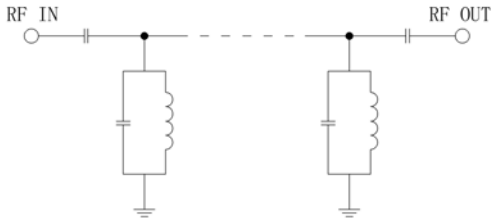
推荐装配图



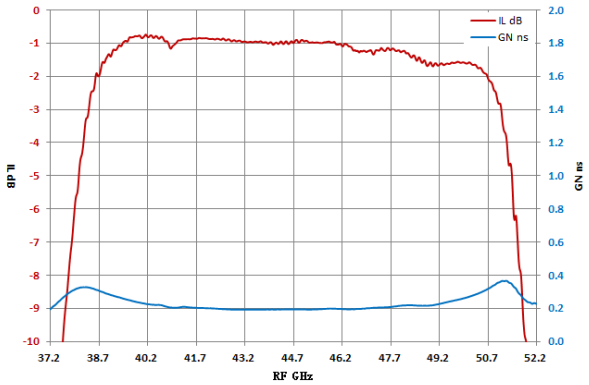
注意事项

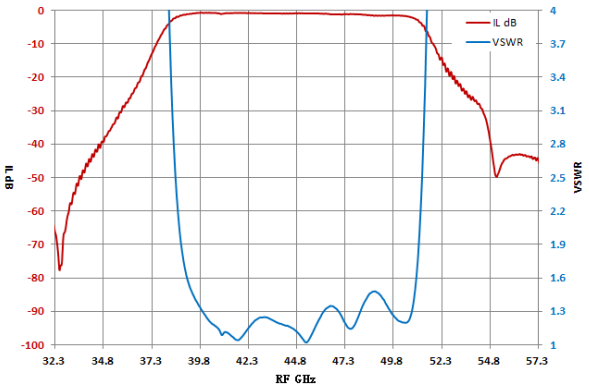
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

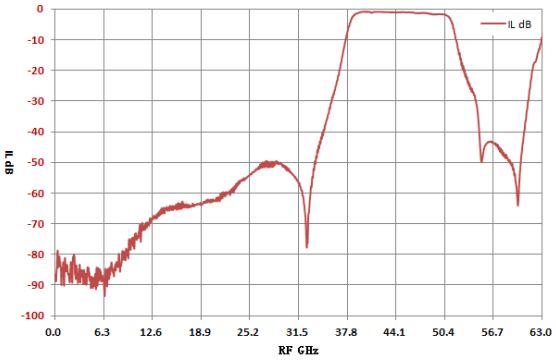
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



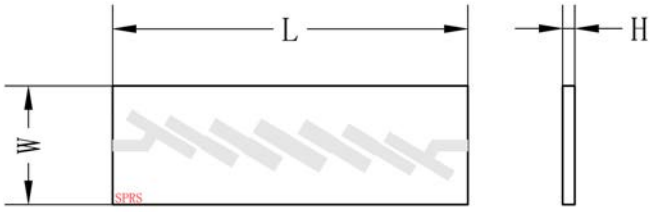
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	44.5	GHz
工作带宽	39.2-49.8	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.2	ns
带外抑制	40@DC-35.0GHz	dBc
带外抑制	30@54.0-55.0GHz	dBc

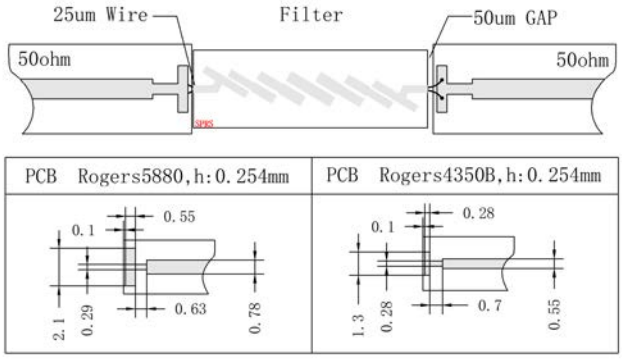
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



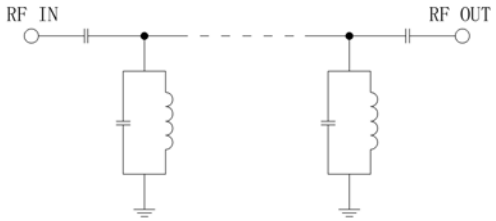
推荐装配图



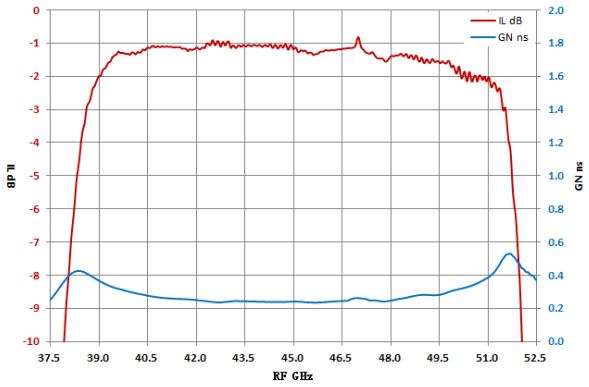
注意事项

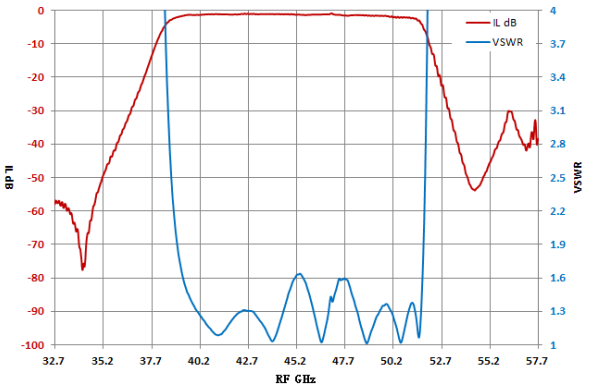
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

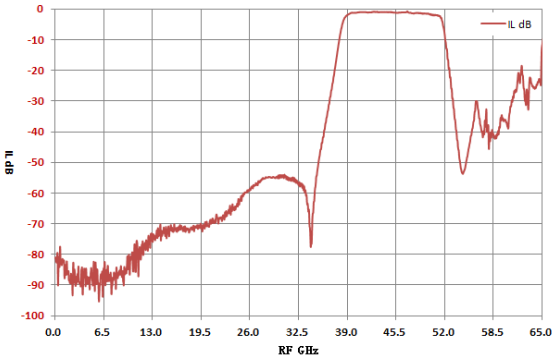
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

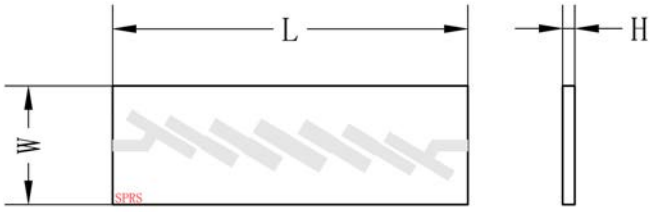
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	45.1	GHz
工作带宽	39.5-50.7	GHz
中心损耗	1.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-33.2GHz	dBc
带外抑制	40@56.0-63.0GHz	dBc

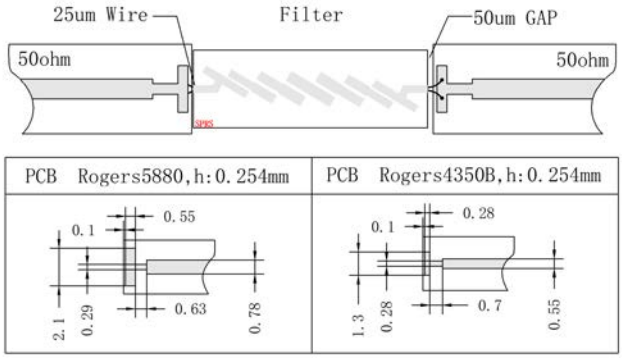
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：1.8，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



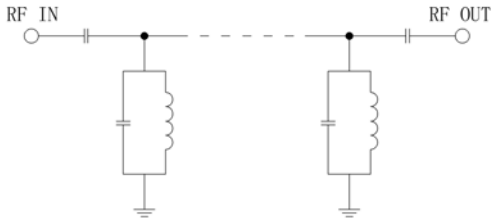
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

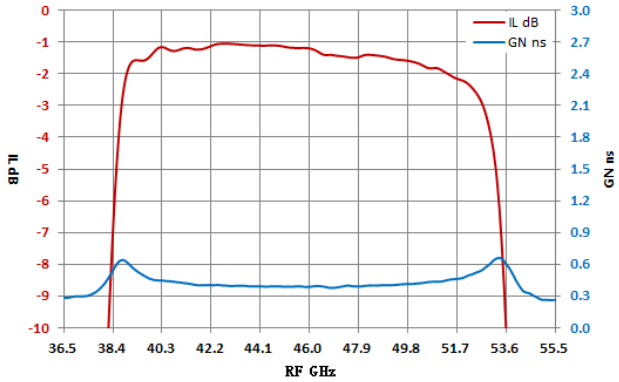
参考实物图

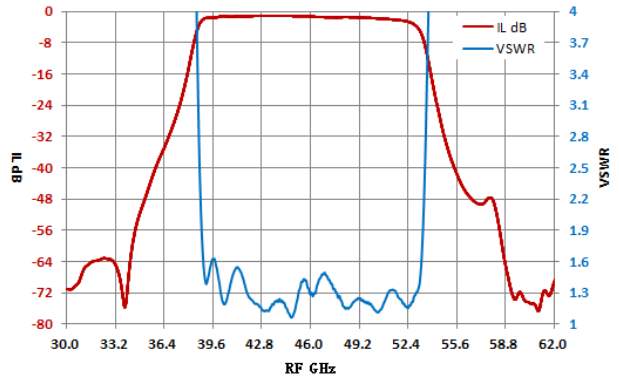


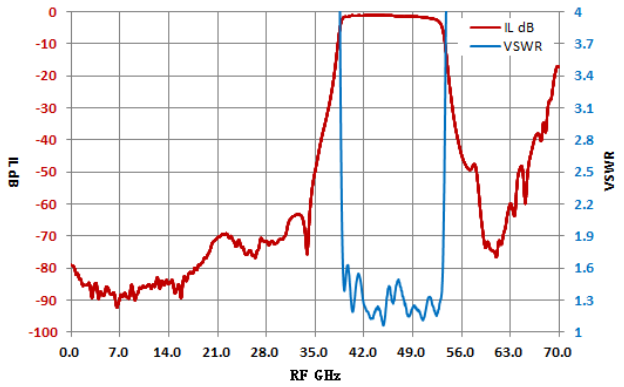
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

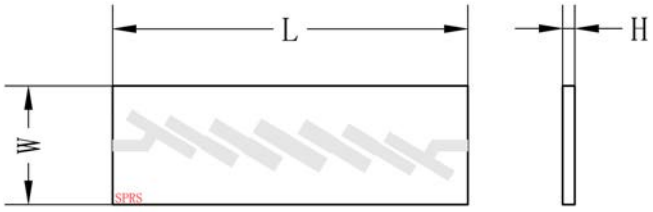
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	40.0	GHz
工作带宽	39.6-40.4	GHz
中心损耗	3.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-38.2GHz	dBc
带外抑制	40@42.2-55.0GHz	dBc

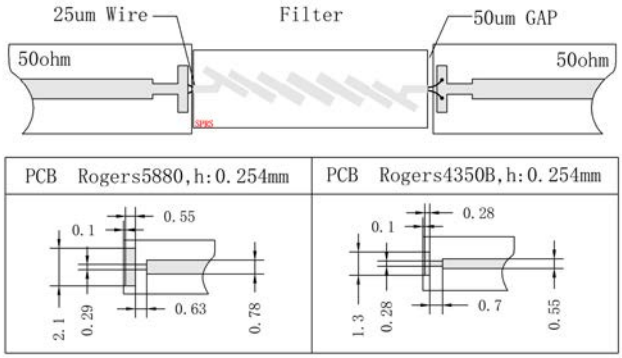
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



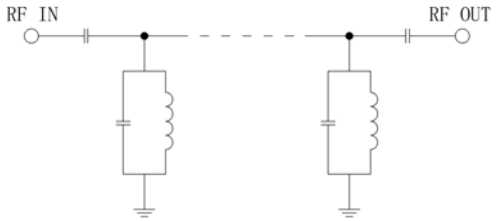
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

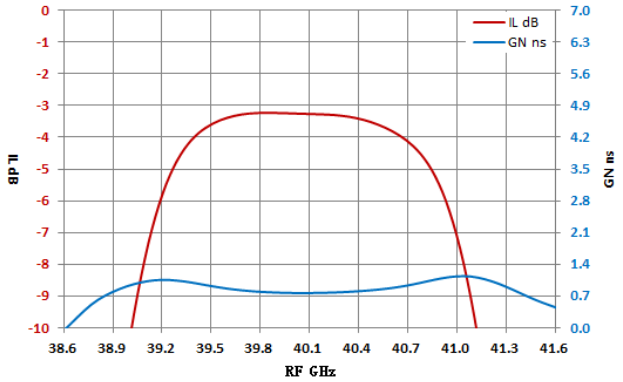
参考实物图

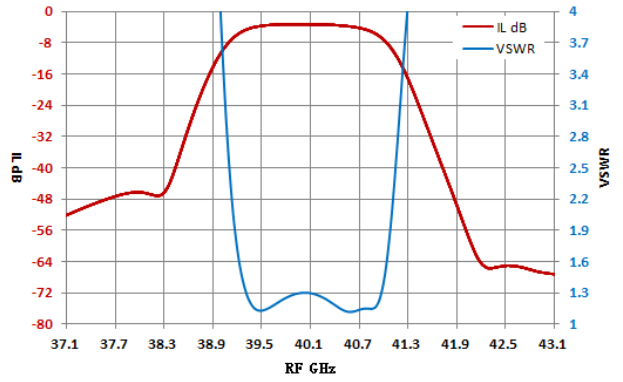


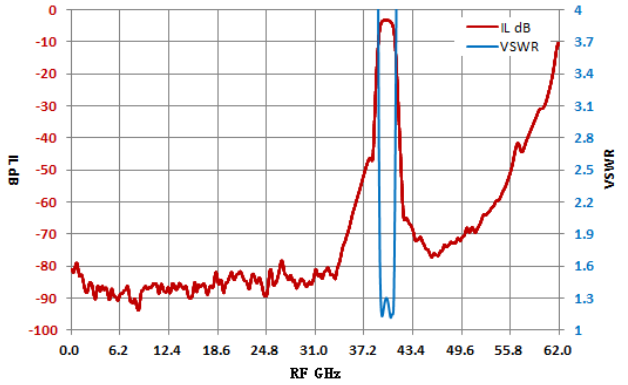
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



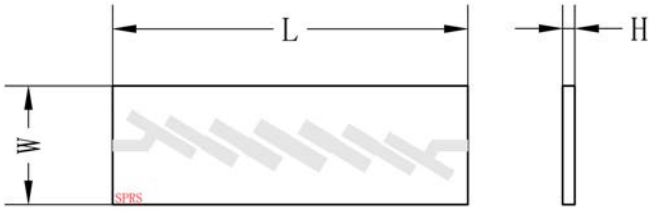
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	40.1	GHz
工作带宽	39.6-40.6	GHz
中心损耗	4.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	30@DC-37.8GHz	dBc
带外抑制	20@47.5-52.0GHz	dBc

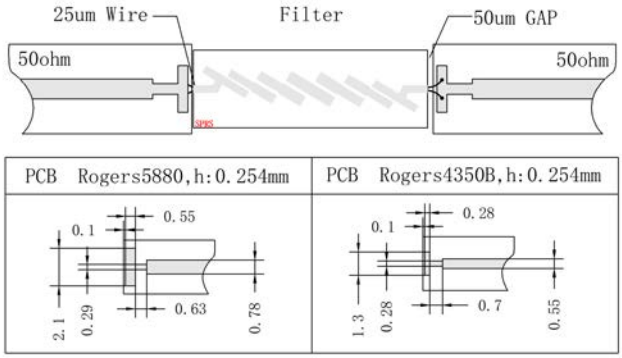
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：4.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



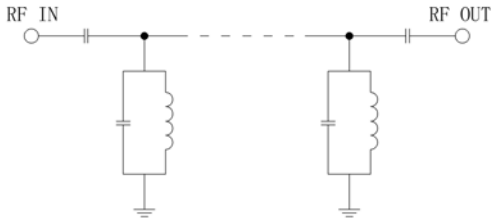
推荐装配图



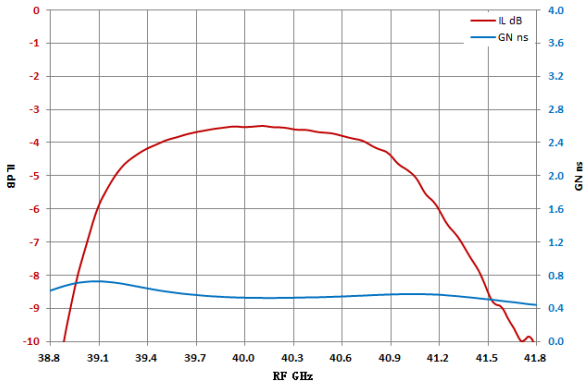
注意事项

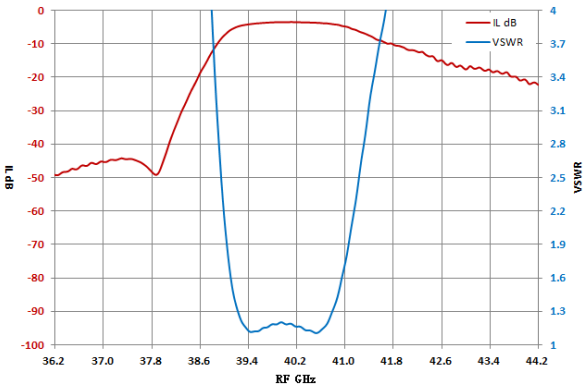
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

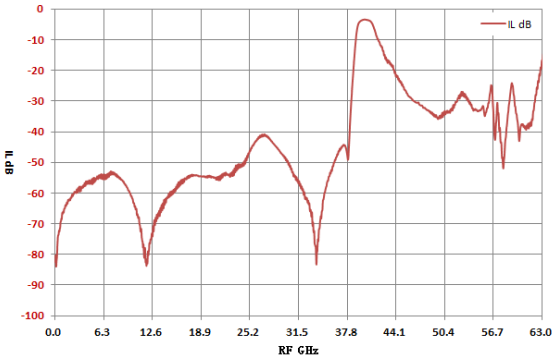
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



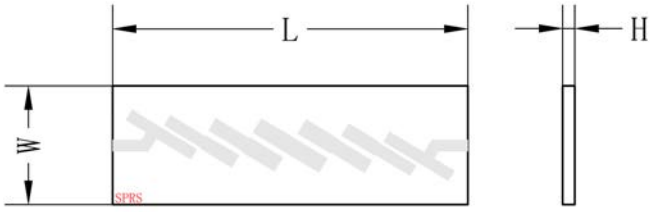
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	44.6	GHz
工作带宽	39.6-49.6	GHz
中心损耗	1.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-35.0GHz	dBc
带外抑制	30@53.8-55.0GHz	dBc

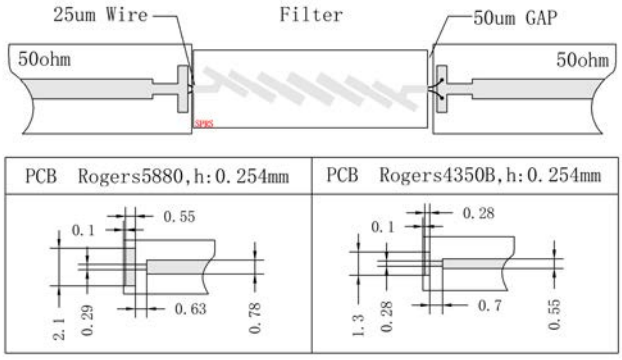
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



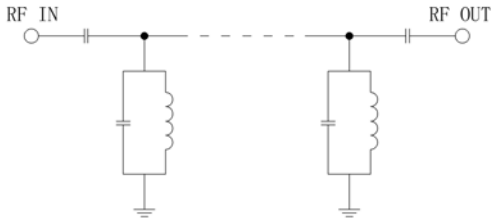
推荐装配图



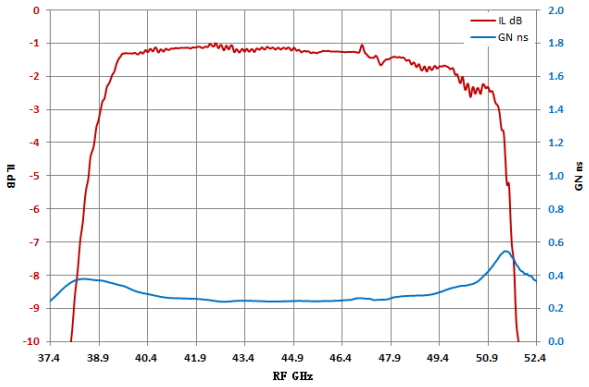
注意事项

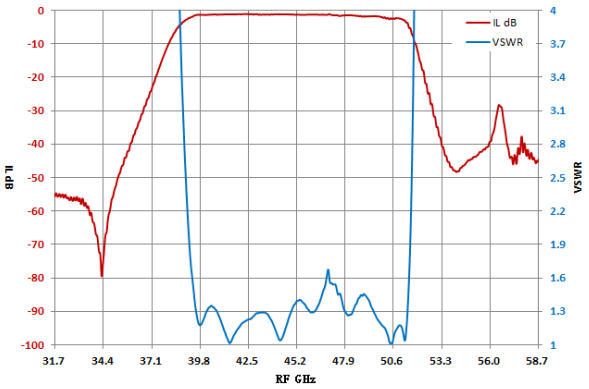
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

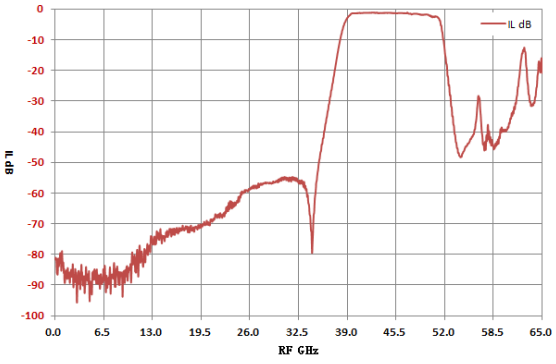
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



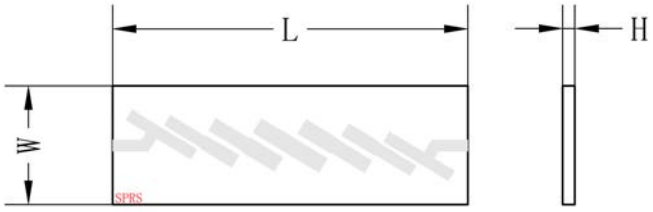
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	41.0	GHz
工作带宽	40.0-42.0	GHz
中心损耗	2.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-35.8GHz	dBc
带外抑制	40@44.5-56.0GHz	dBc

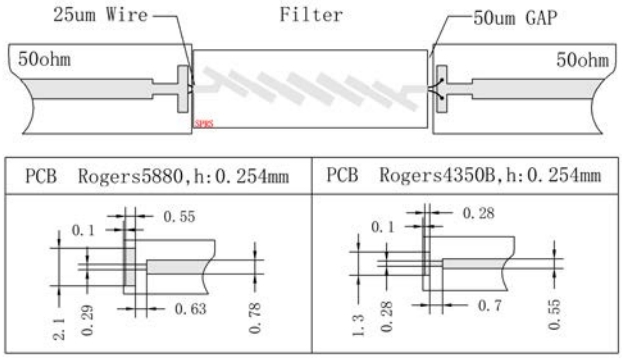
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：5.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



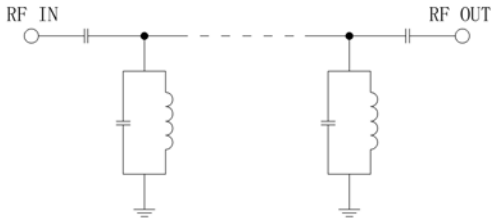
推荐装配图



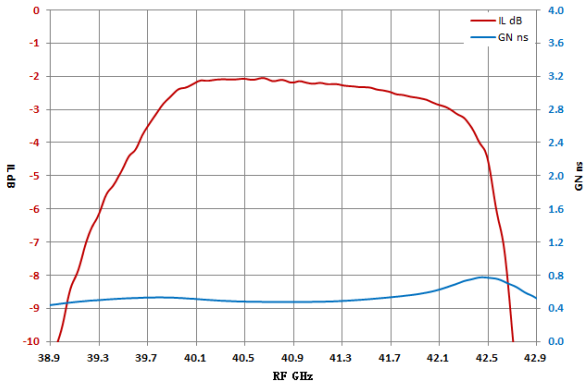
注意事项

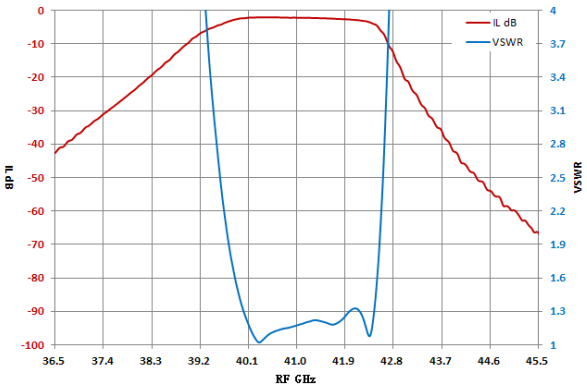
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

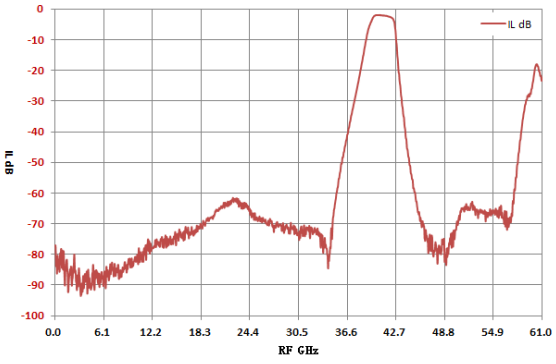
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

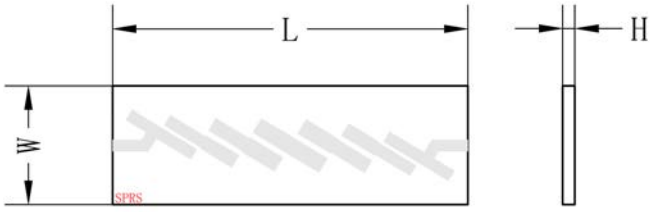
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	41.9	GHz
工作带宽	40.0-43.8	GHz
中心损耗	2.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-37.4GHz	dBc
带外抑制	40@46.5-50.0GHz	dBc

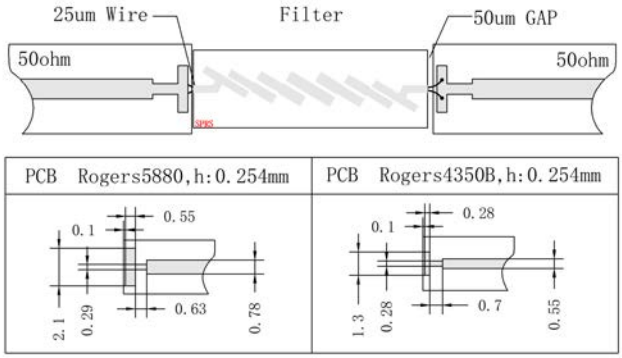
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



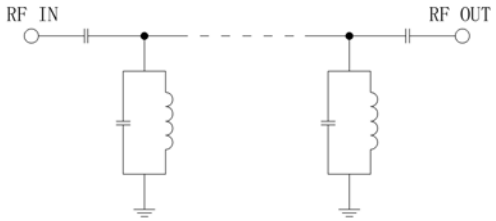
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖175mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

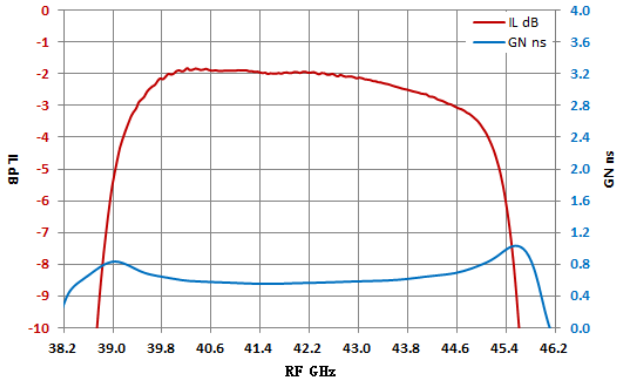
参考实物图

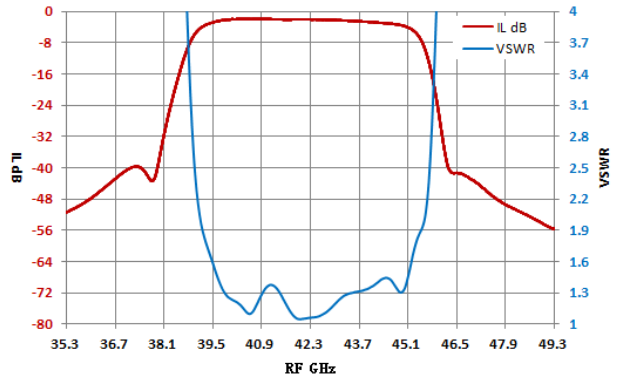


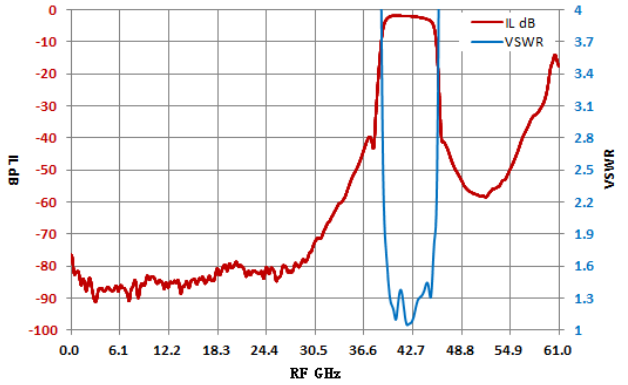
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



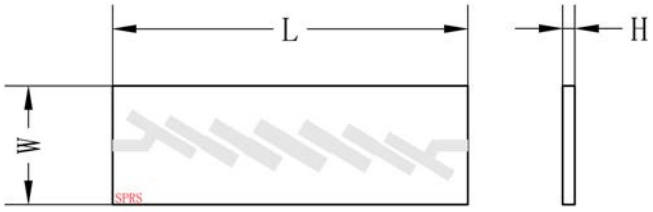
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	42.1	GHz
工作带宽	40.0-44.2	GHz
中心损耗	2.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-36.2GHz	dBc
带外抑制	40@46.5-53.0GHz	dBc

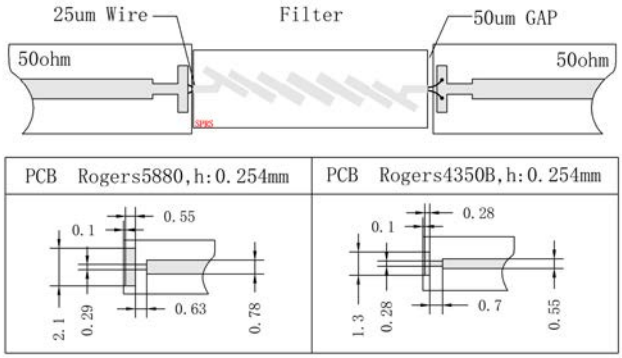
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



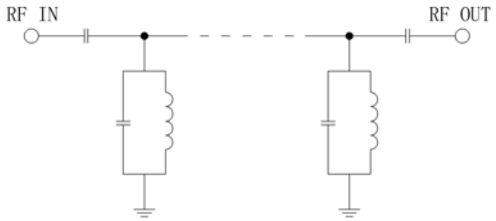
推荐装配图



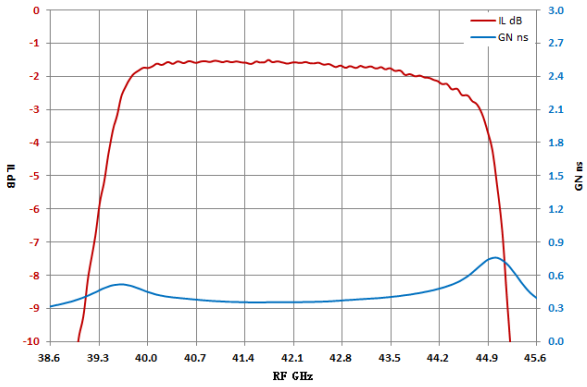
注意事项

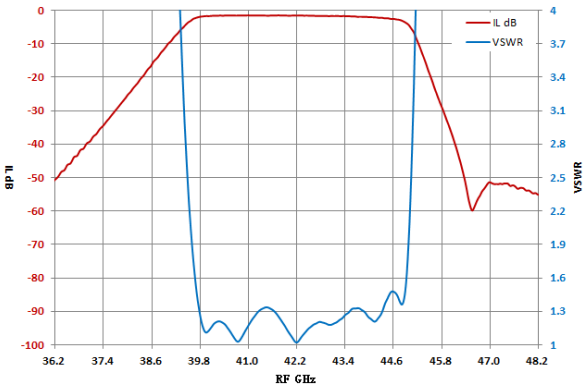
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

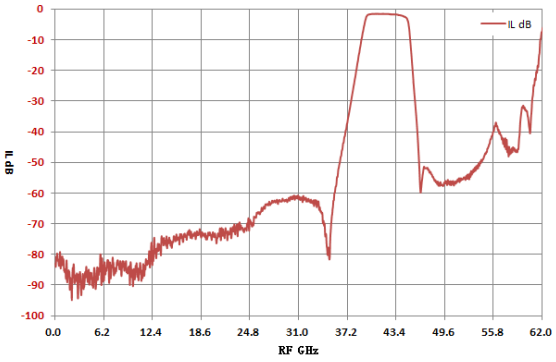
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



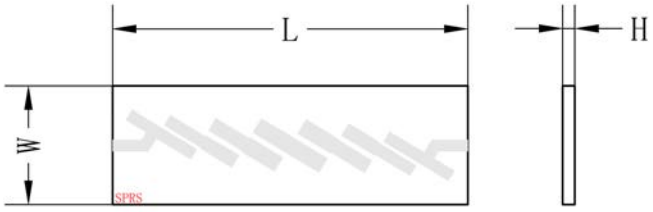
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	45.2	GHz
工作带宽	40.8-49.6	GHz
中心损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-37.7GHz	dBc
带外抑制	40@53.7-56.0GHz	dBc

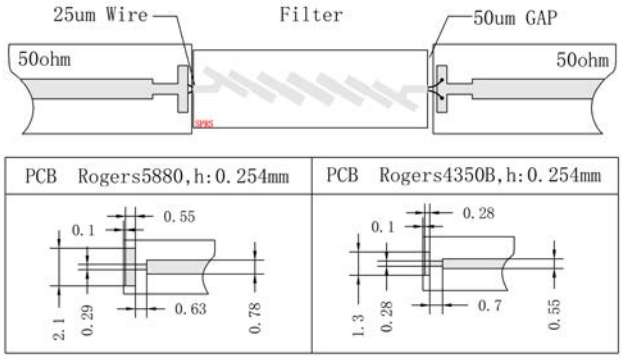
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



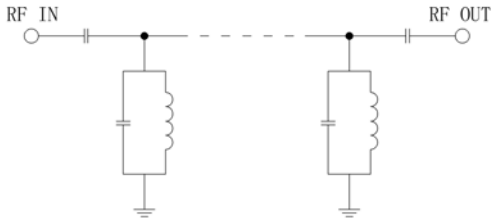
推荐装配图



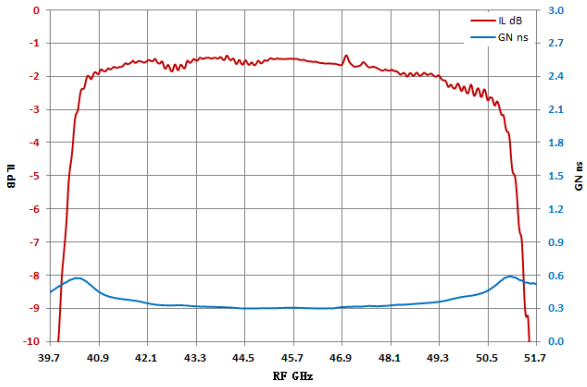
注意事项

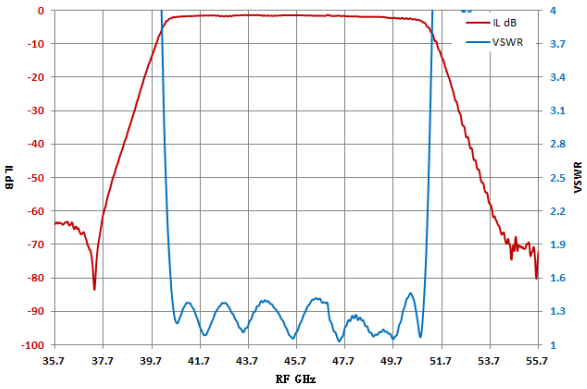
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

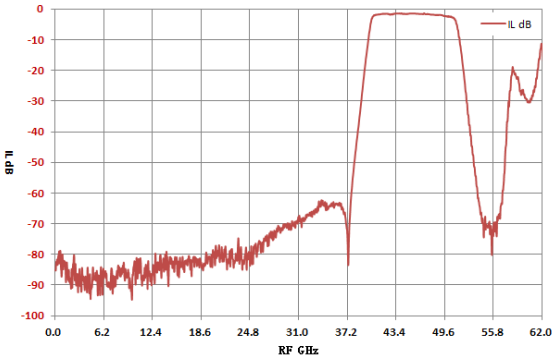
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

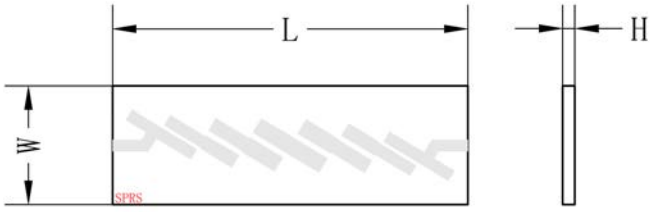
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	46.3	GHz
工作带宽	40.8-51.8	GHz
中心损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-33.0GHz	dBc
带外抑制	40@58.0-63.0GHz	dBc

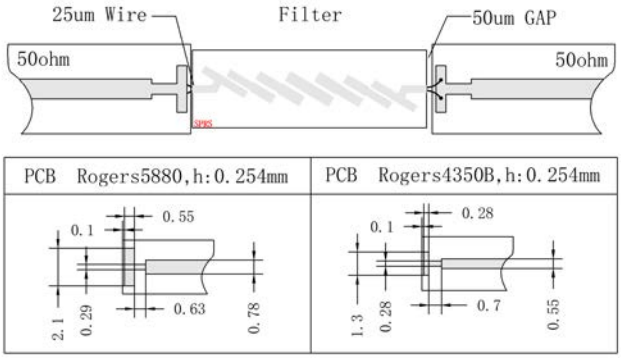
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：1.8，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



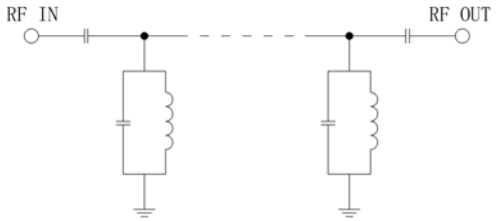
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

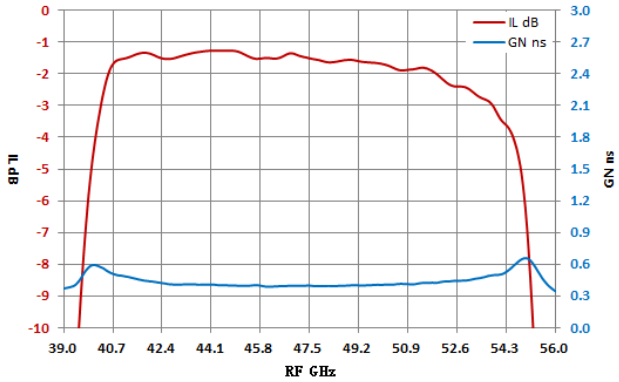
参考实物图

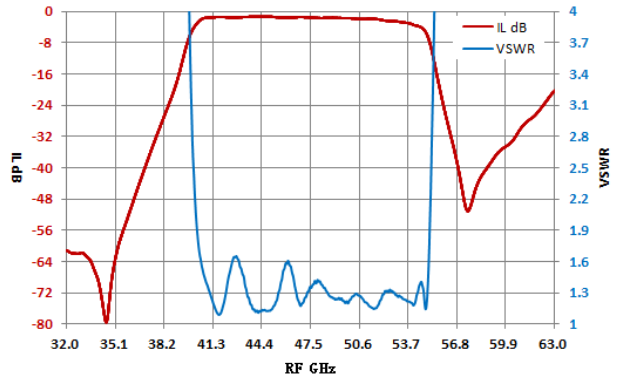


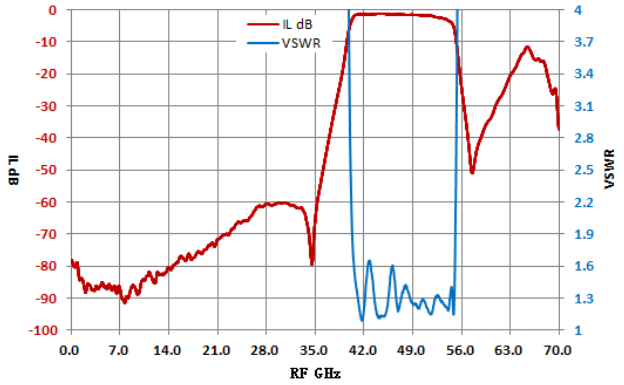
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

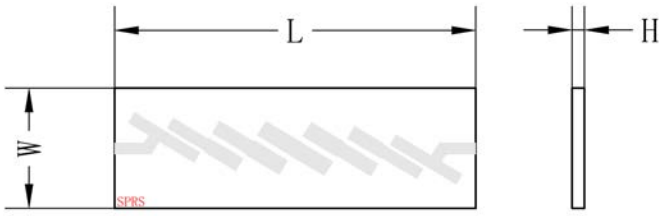
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	42.9	GHz
工作带宽	41.0-44.8	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	35@DC-38.5GHz	dBc
带外抑制	30@47.4-60.0GHz	dBc

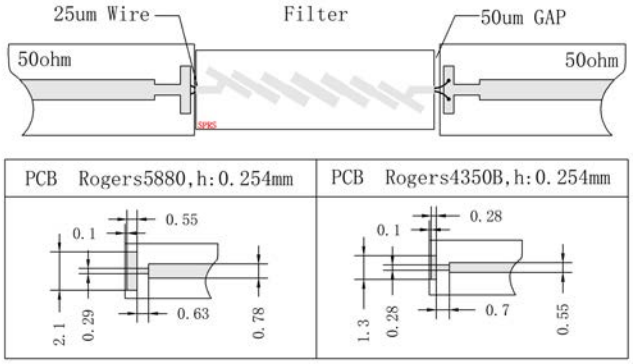
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：6.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

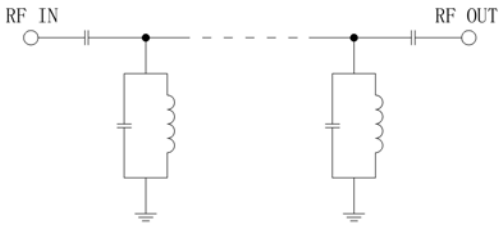
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

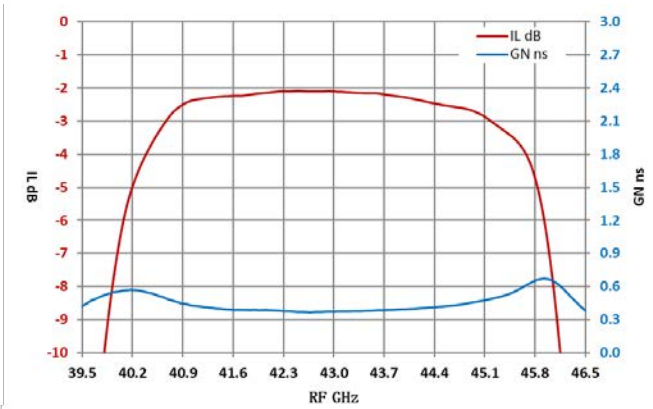
参考图

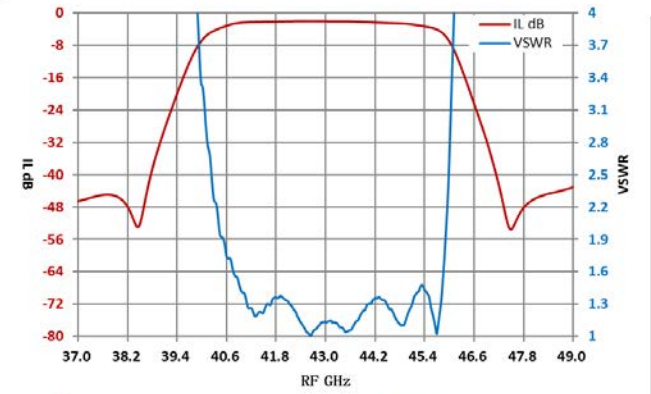


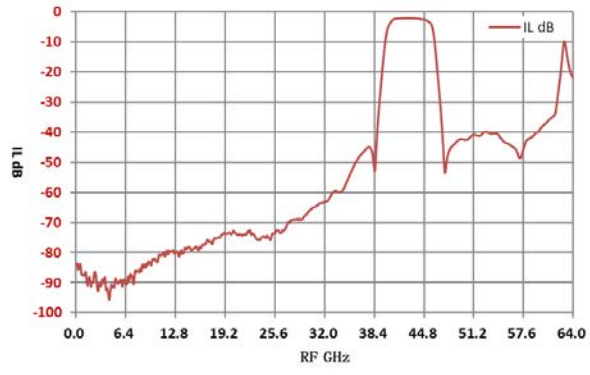
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

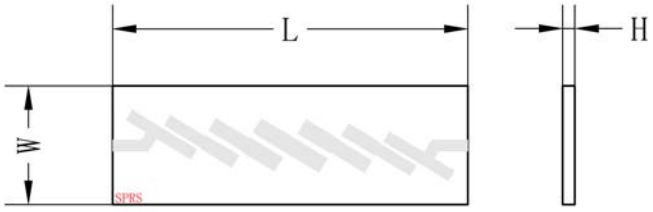
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	42.2	GHz
工作带宽	41.2-43.2	GHz
中心损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.7	ns
带外抑制	40@DC-38.3GHz	dBc
带外抑制	40@45.1-46.0GHz	dBc

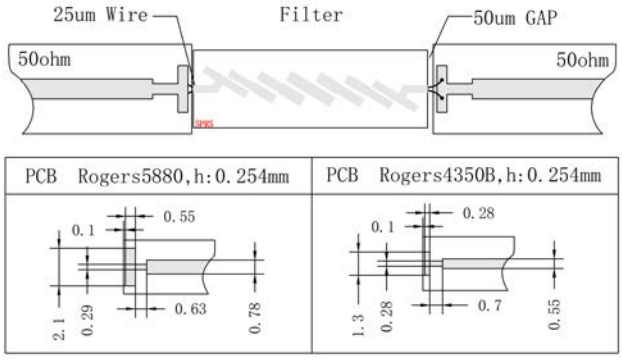
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



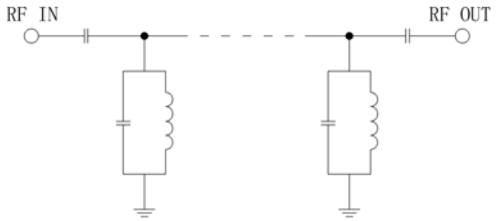
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

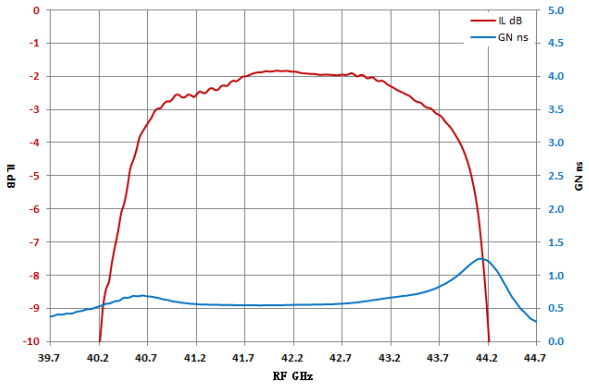
参考实物图

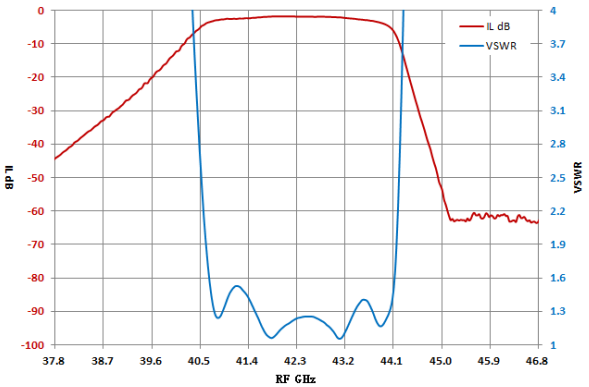


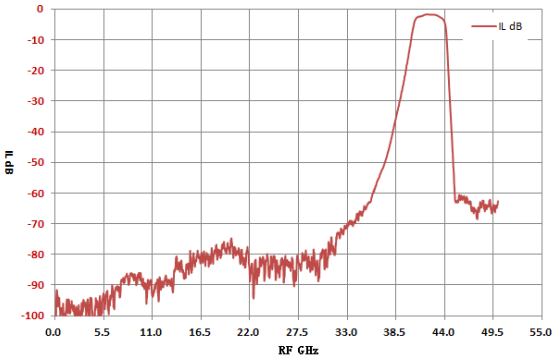
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



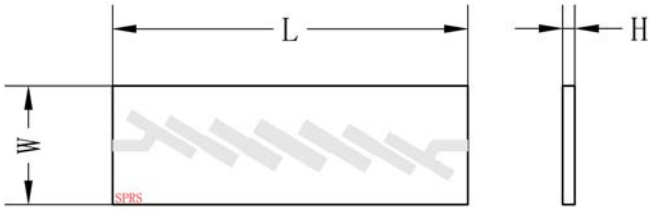
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	44.4	GHz
工作带宽	41.2-47.6	GHz
中心损耗	2.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-37.5GHz	dBc
带外抑制	40@52.7-60.0GHz	dBc

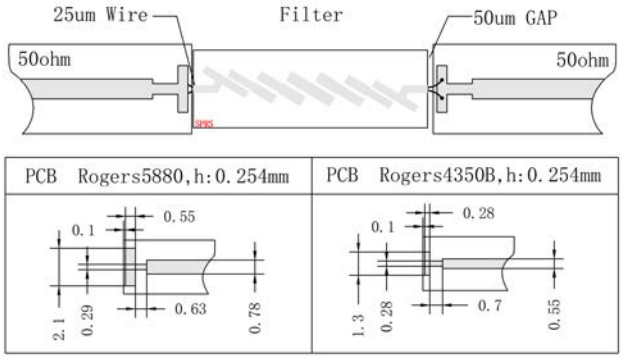
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：1.8，h：0.26

外形图：端口居中



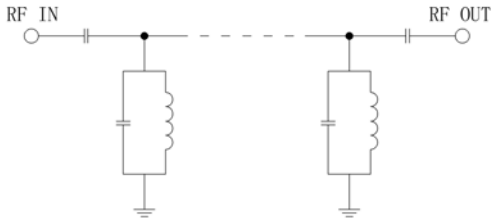
推荐装配图



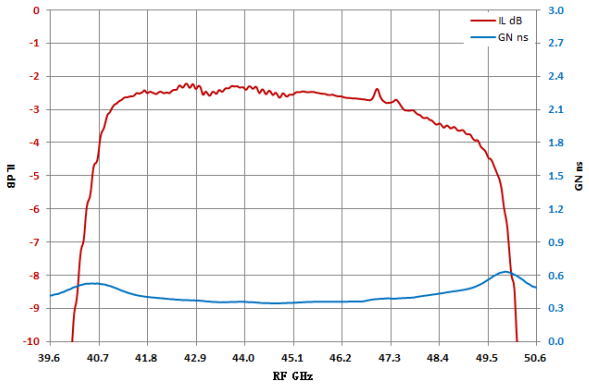
注意事项

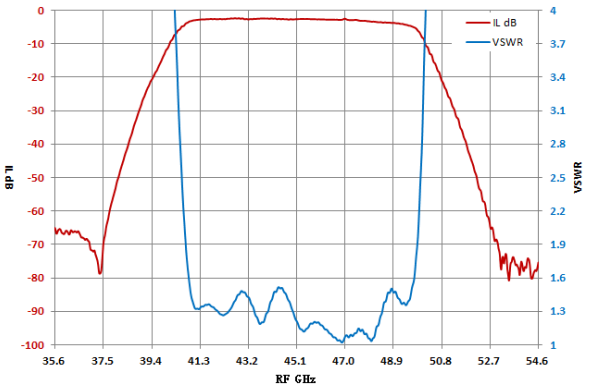
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

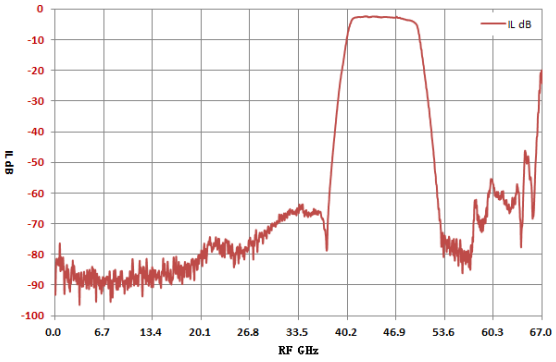
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

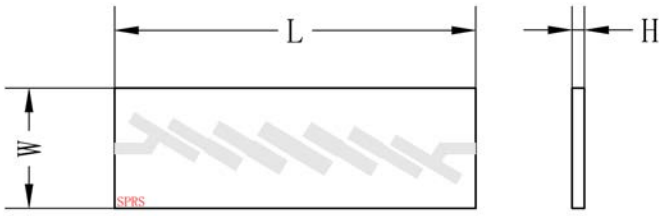
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	43.85	GHz
工作带宽	41.6-46.1	GHz
中心损耗	3.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	35@DC-39.0GHz	dBc
带外抑制	30@49.0-60.0GHz	dBc

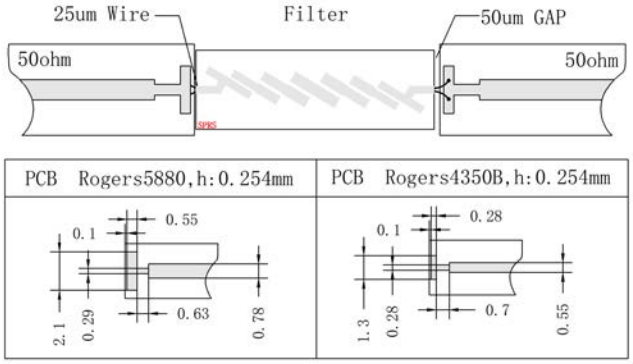
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：5.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

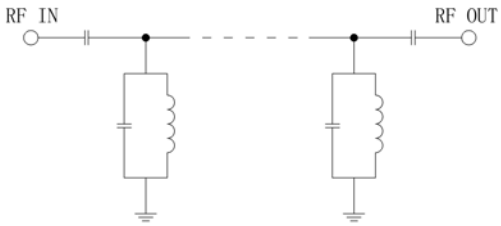
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

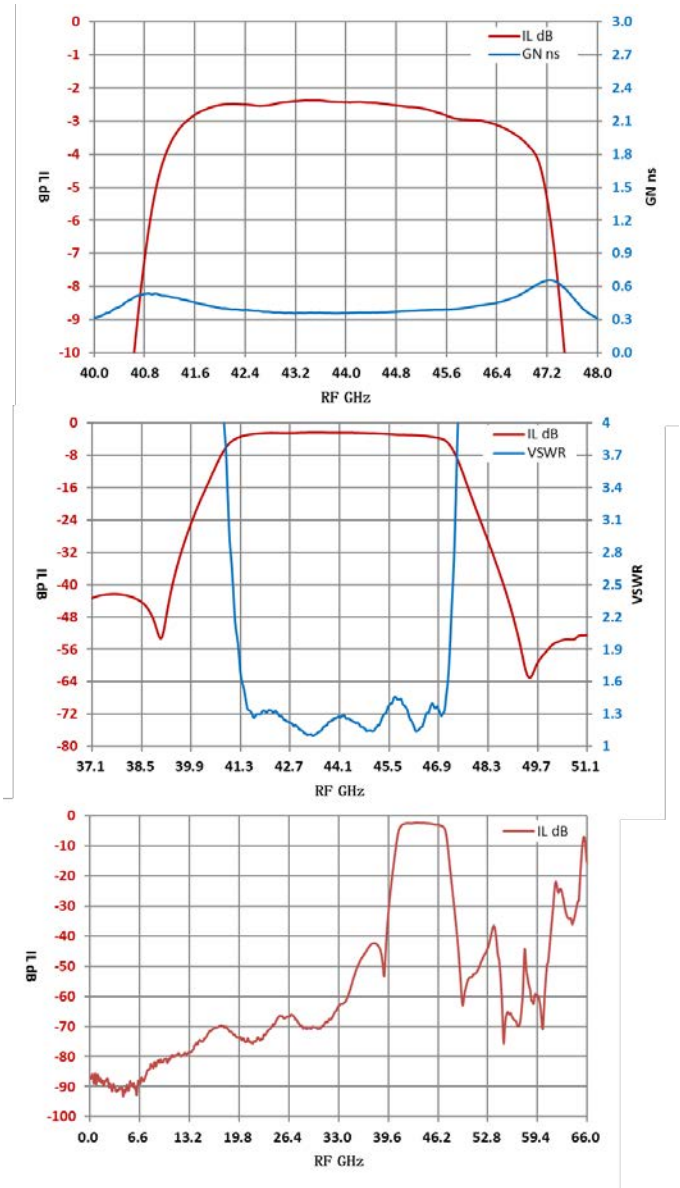
参考图



原理图



典型曲线



产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

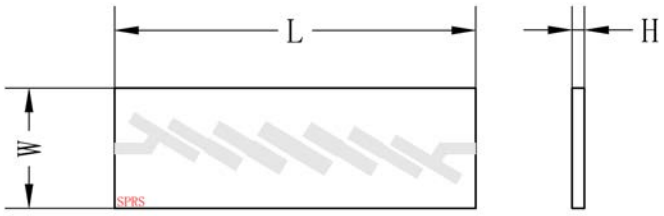
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	47.2	GHz
工作带宽	44.2-50.2	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	30@DC-41.8GHz	dBc
带外抑制	20@53.0-61.0GHz	dBc

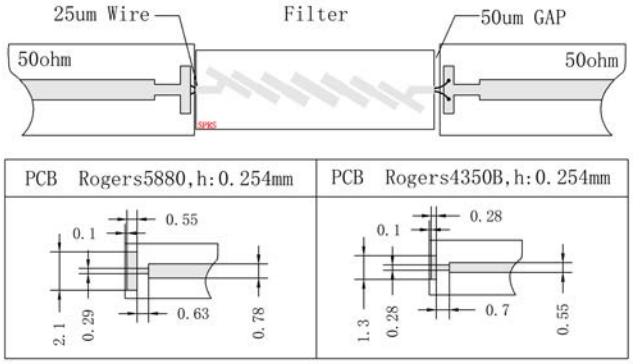
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：6.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

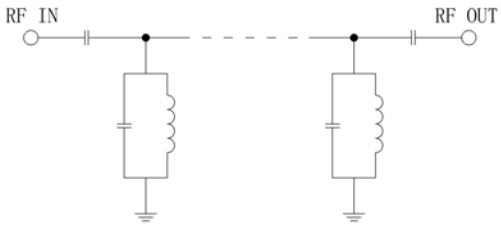
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

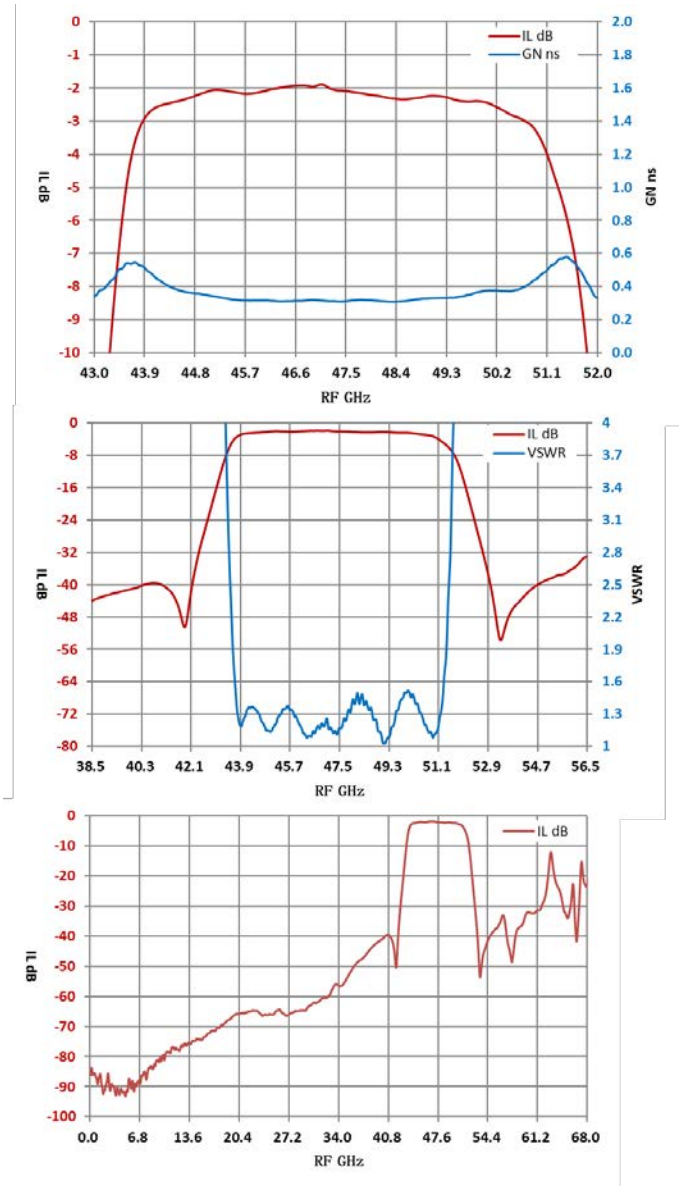
参考图



原理图



典型曲线



产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

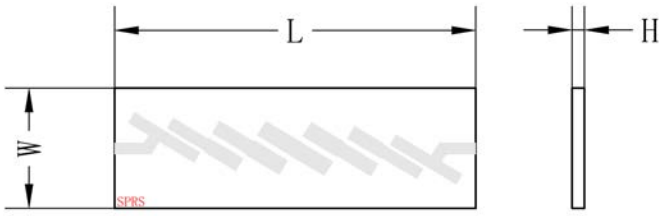
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	46.3	GHz
工作带宽	42.4-50.2	GHz
中心损耗	3.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-38.8GHz	dBc
带外抑制	40@55.2-64.0GHz	dBc

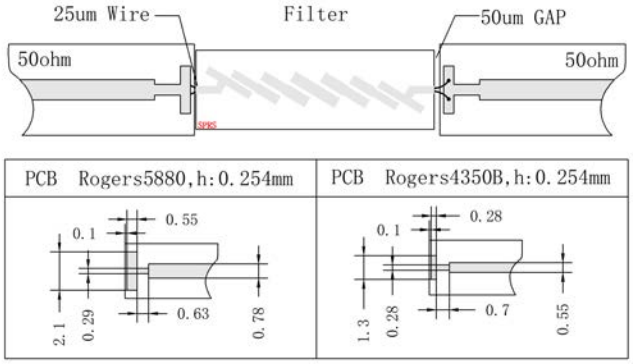
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：6.5，W：2.0，h：0.13

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.87mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

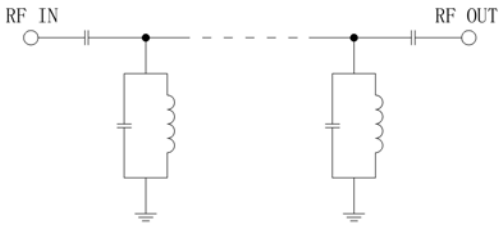
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

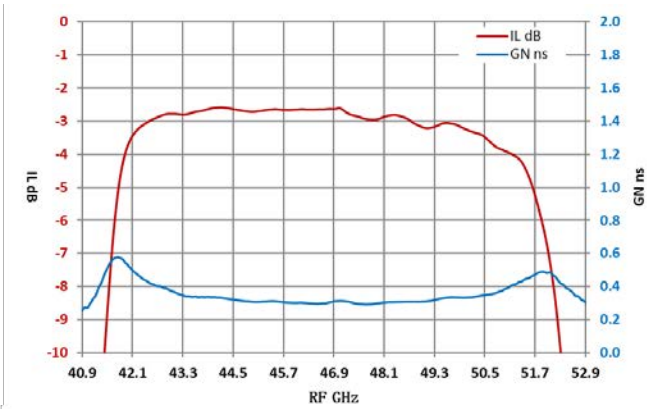
参考图

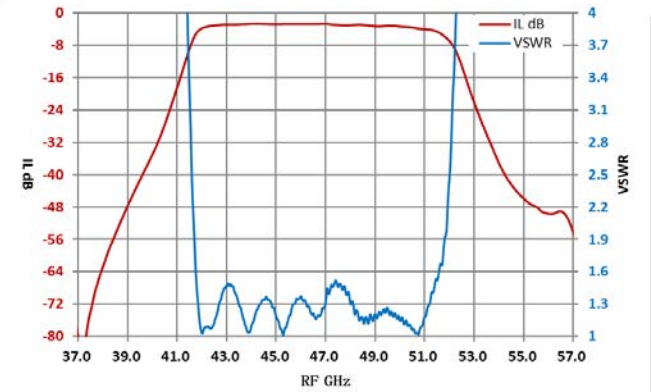


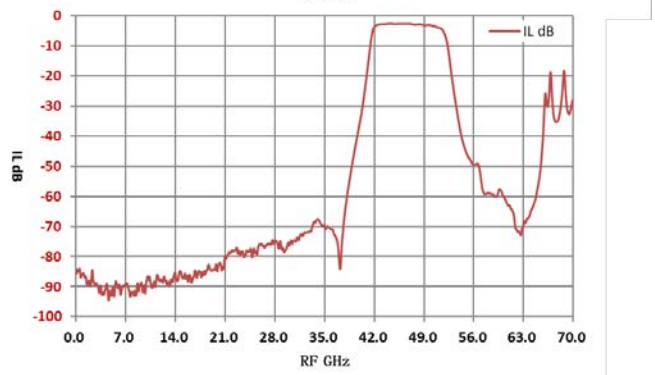
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



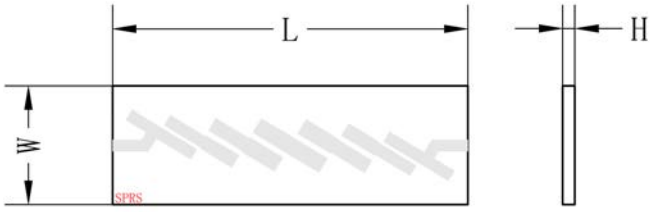
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	44.6	GHz
工作带宽	43.6-45.6	GHz
中心损耗	3.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-41.2GHz	dBc
带外抑制	40@47.8-58.0GHz	dBc

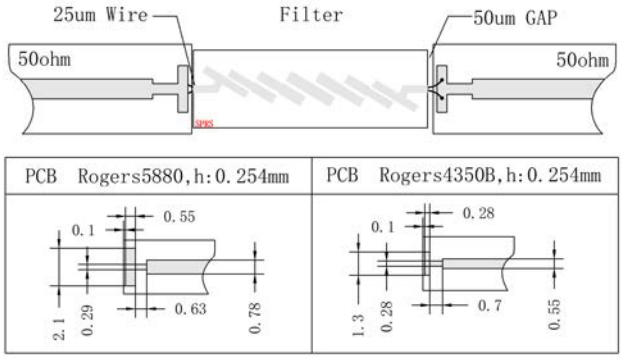
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



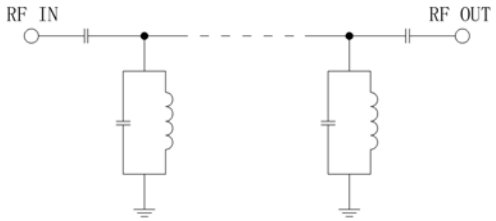
推荐装配图



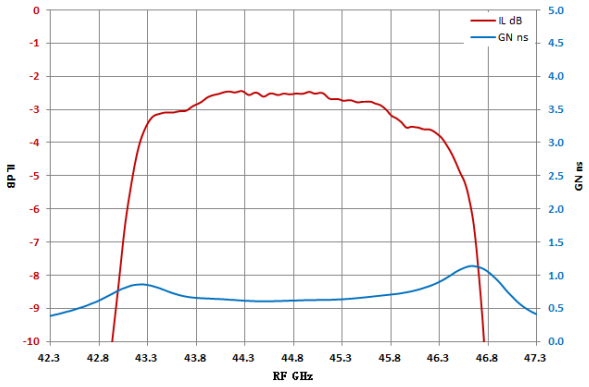
注意事项

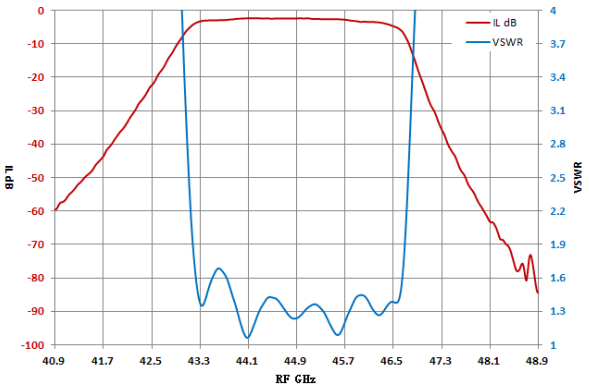
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

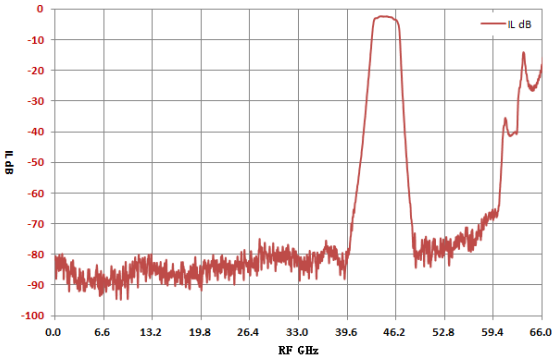
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

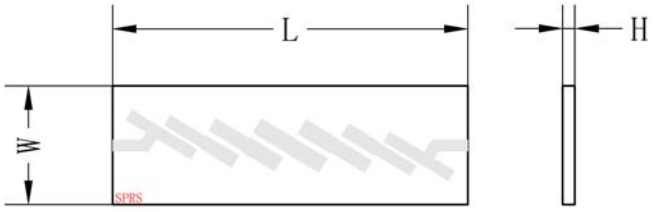
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	47.5	GHz
工作带宽	43.8-51.2	GHz
中心损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-38.5GHz	dBc
带外抑制	40@56.2-63.0GHz	dBc

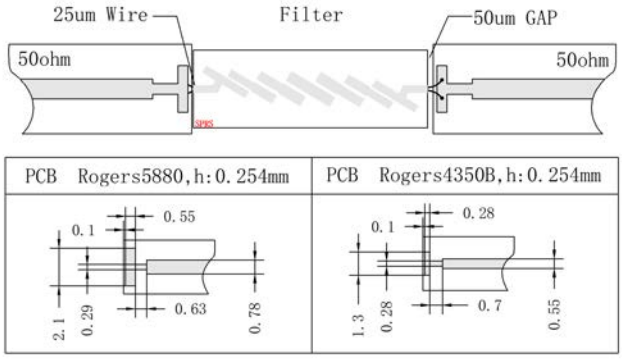
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：1.8，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



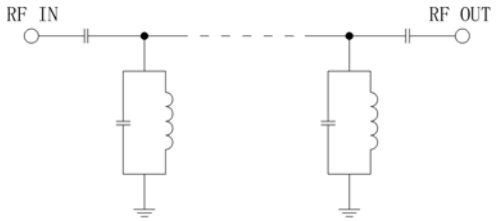
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.87mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

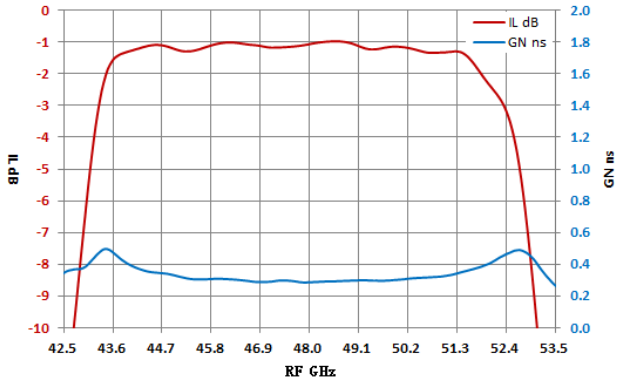
参考实物图

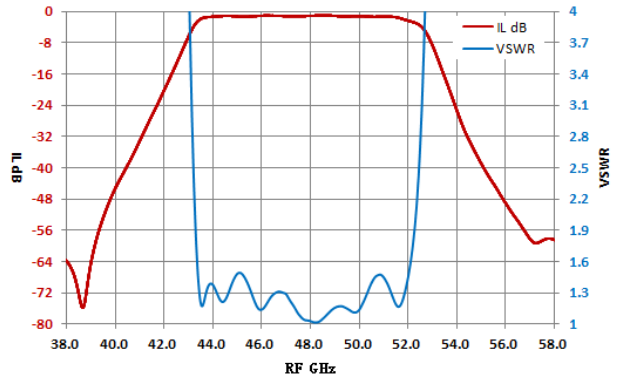


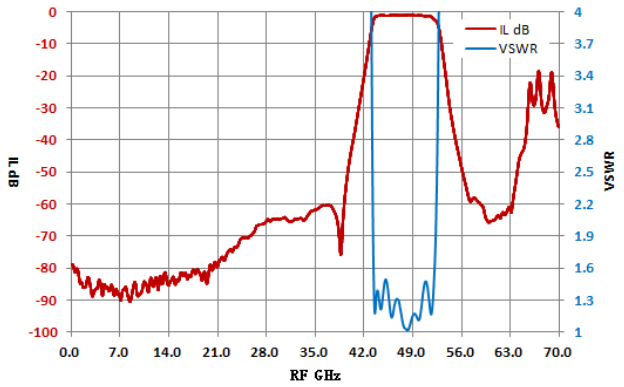
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



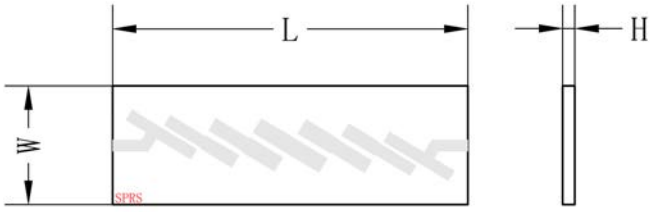
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	46.0	GHz
工作带宽	43.9-48.1	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-40.6GHz	dBc
带外抑制	40@51.0-53.0GHz	dBc

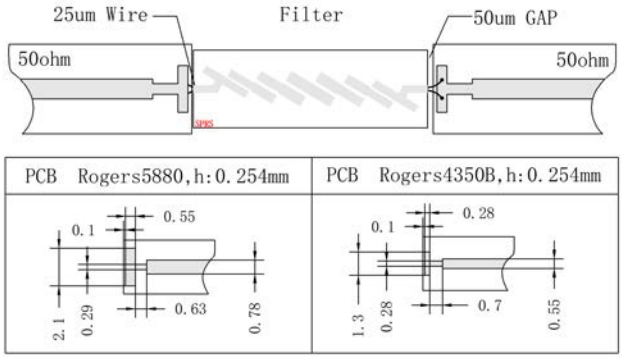
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



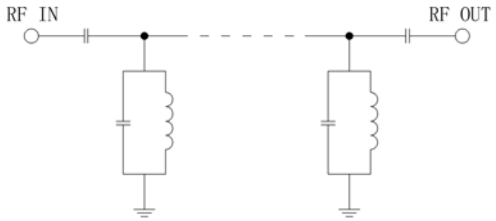
推荐装配图



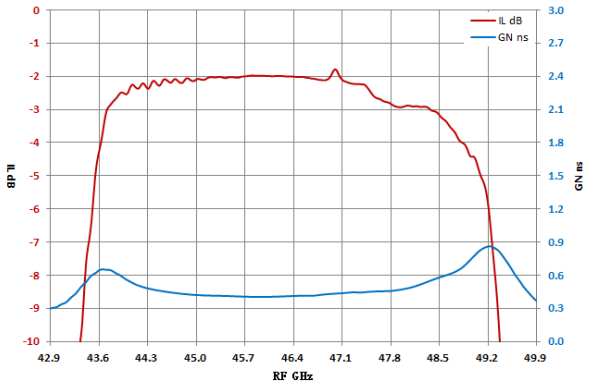
注意事项

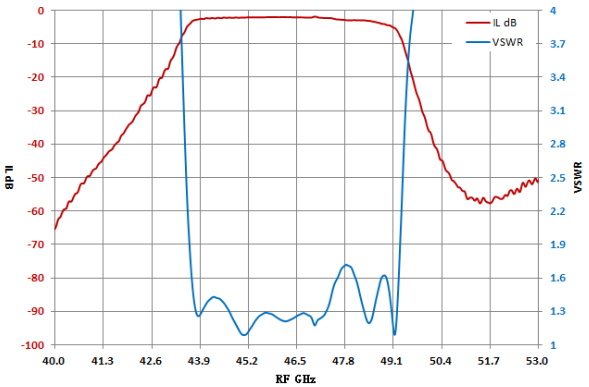
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

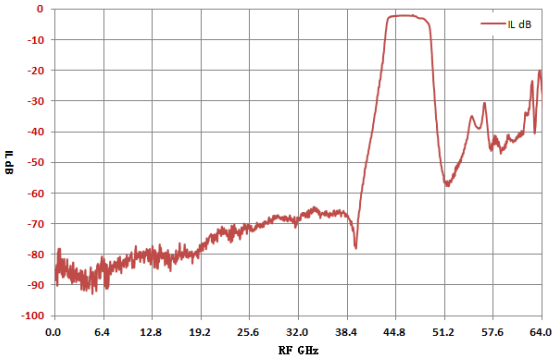
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

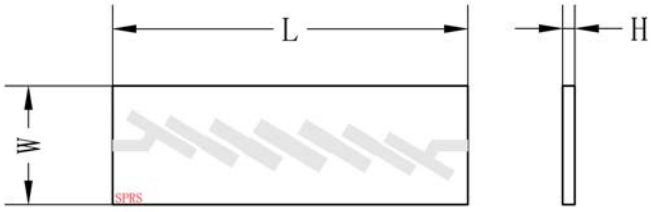
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	48.3	GHz
工作带宽	44.8-51.8	GHz
中心损耗	2.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-35.2GHz	dBc
带外抑制	40@55.8-58.0GHz	dBc

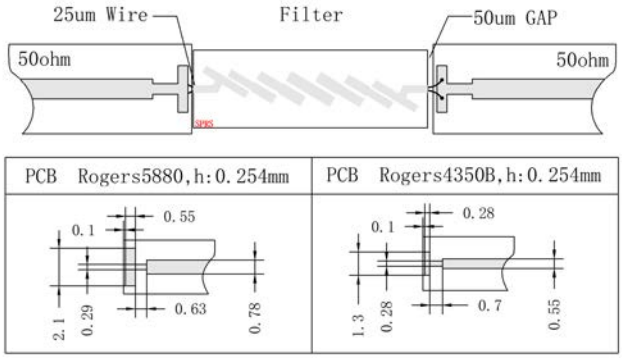
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：1.8，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



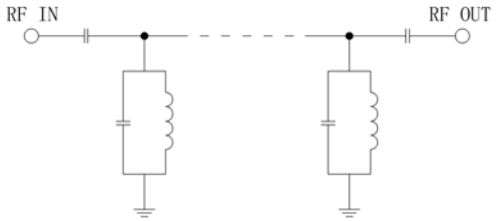
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

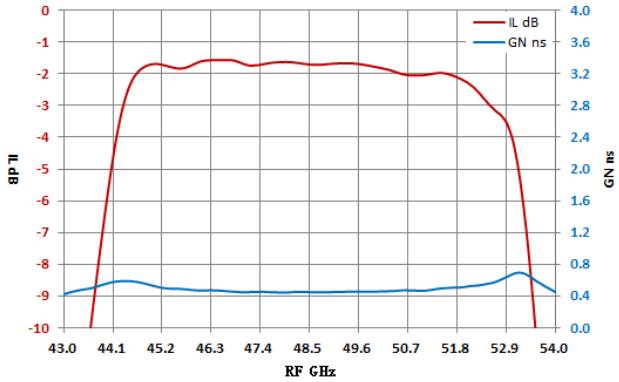
参考实物图

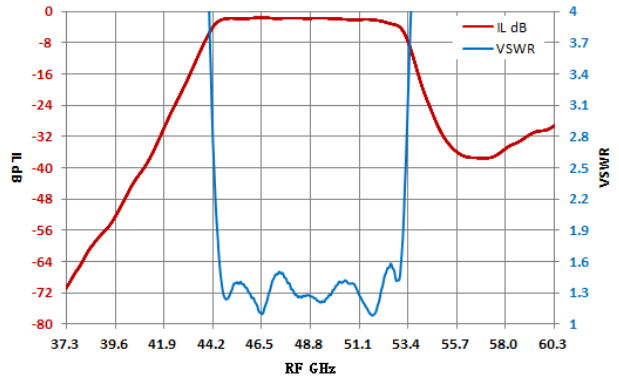


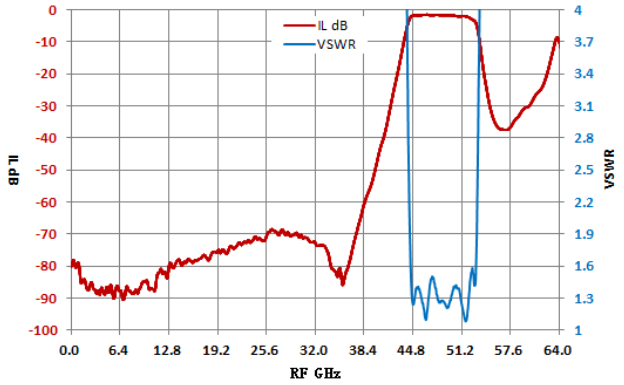
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

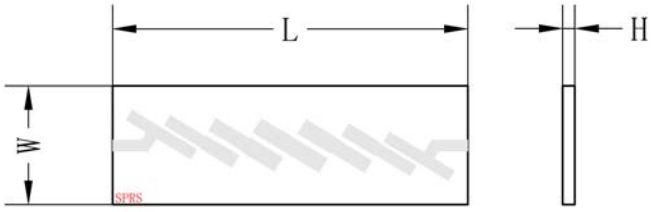
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	45.8	GHz
工作带宽	45.0-46.6	GHz
中心损耗	2.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-42.5GHz	dBc
带外抑制	40@48.8-59.0GHz	dBc

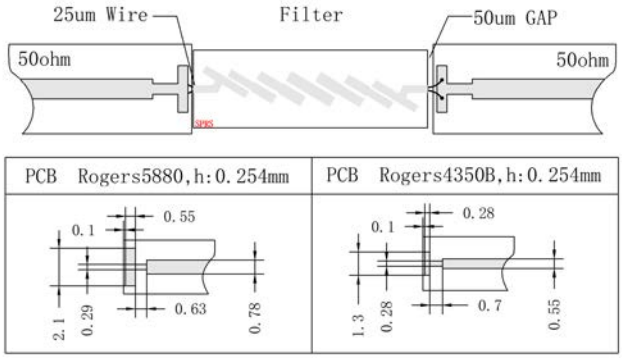
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



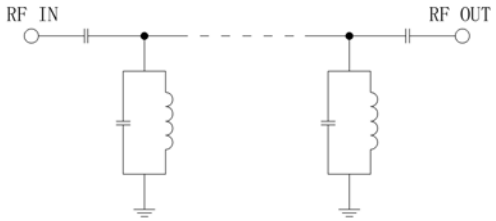
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

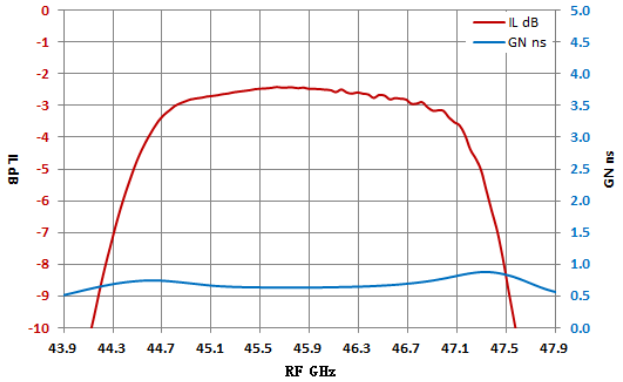
参考实物图

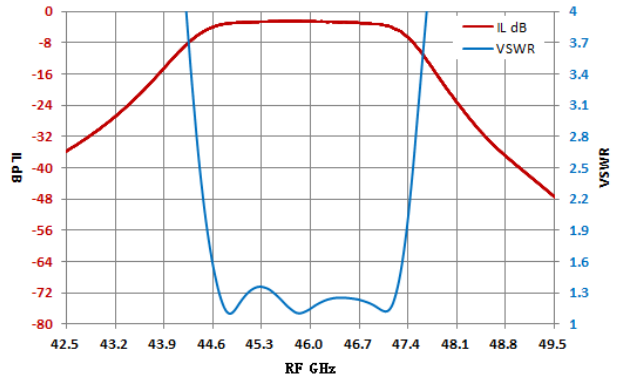


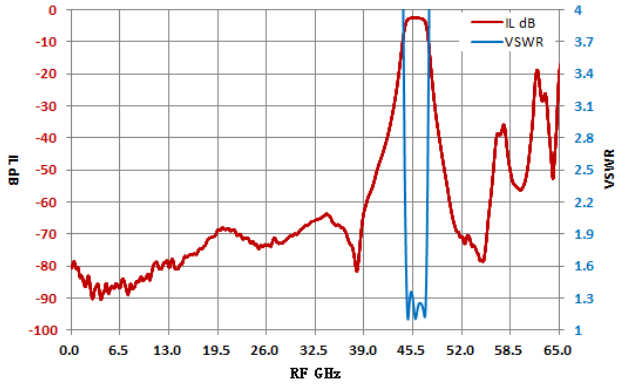
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

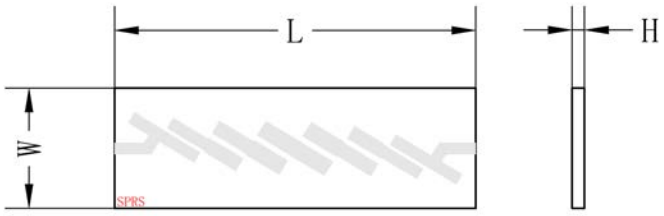
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	47.75	GHz
工作带宽	45.5-50.0	GHz
中心损耗	3.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.8:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	25@DC-42.8GHz	dBc
带外抑制	20@52.8-61.0GHz	dBc

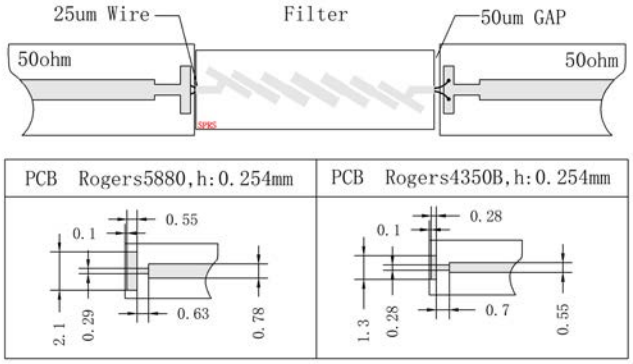
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：5.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

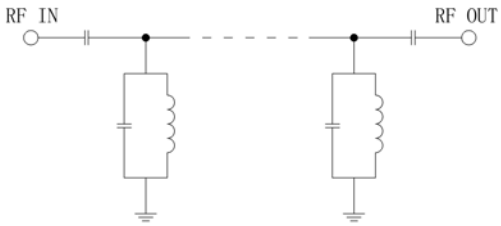
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

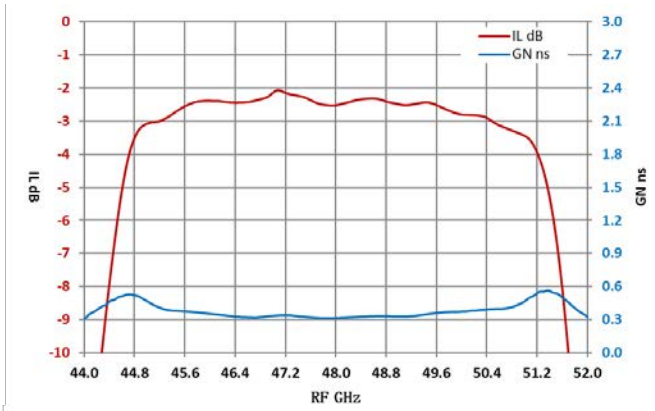
参考图

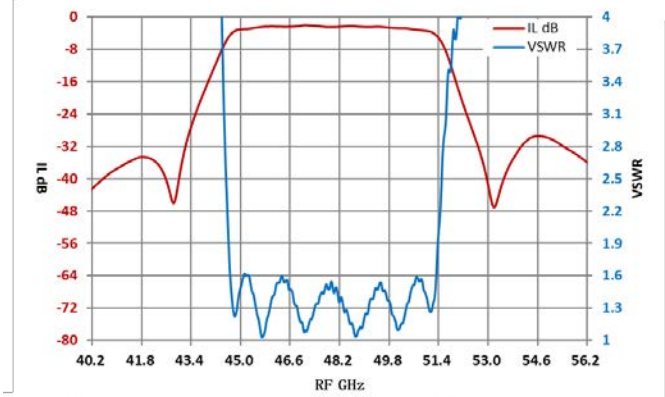


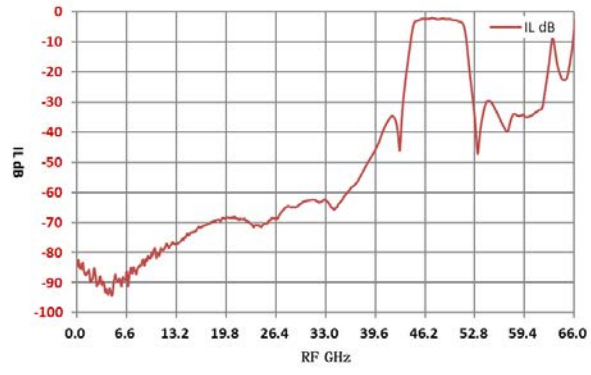
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

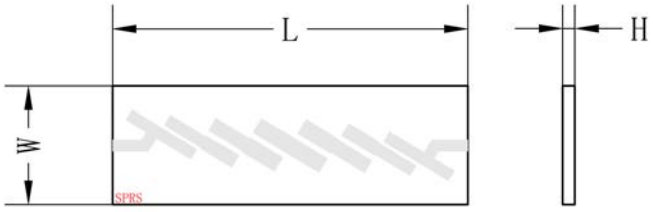
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	48.75	GHz
工作带宽	45.5-52.0	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-40.0GHz	dBc
带外抑制	40@55.2-62.0GHz	dBc

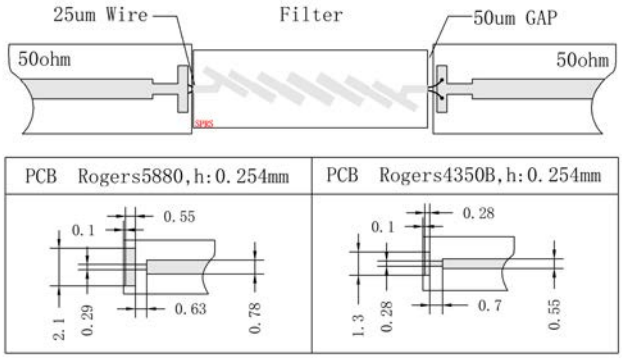
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



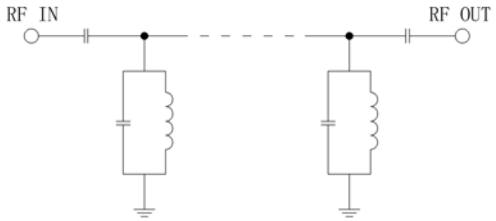
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

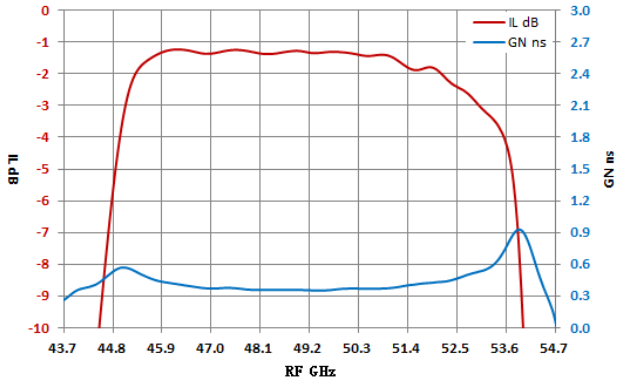
参考实物图

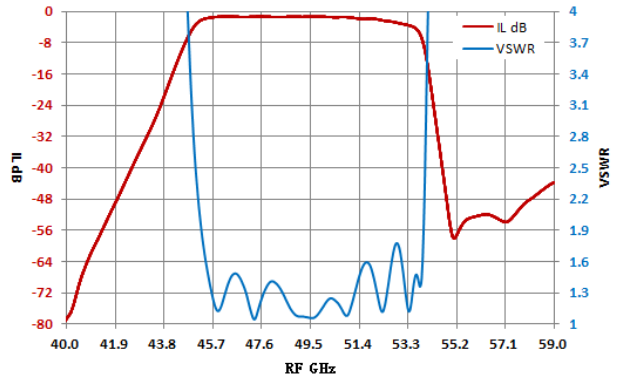


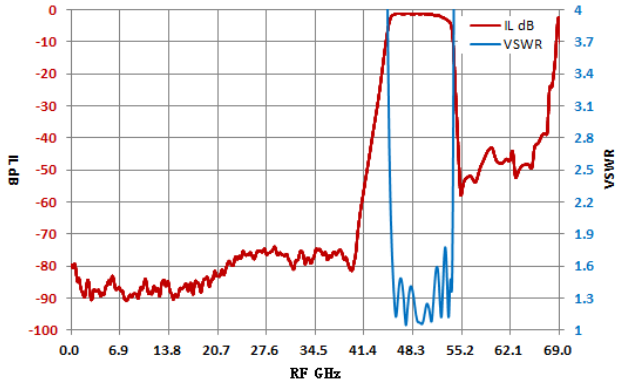
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

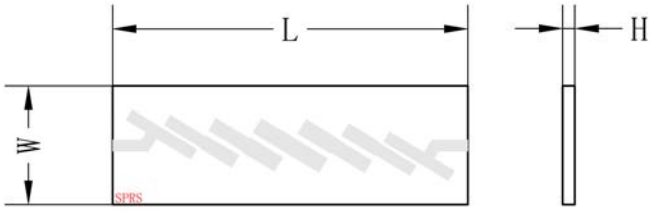
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	49.7	GHz
工作带宽	46.4-53.0	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-40.5GHz	dBc
带外抑制	40@58.0-64.0GHz	dBc

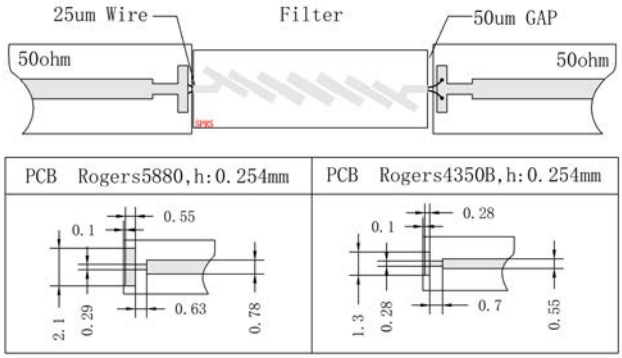
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：1.8，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



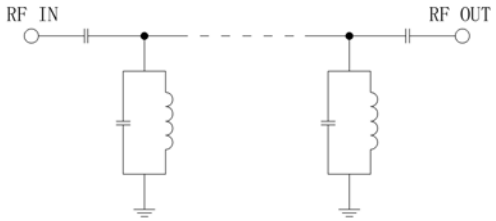
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

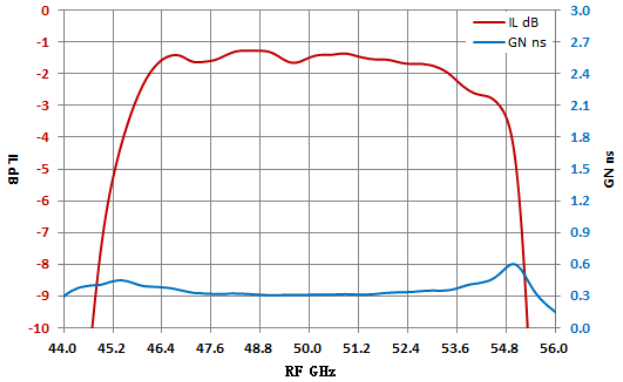
参考实物图

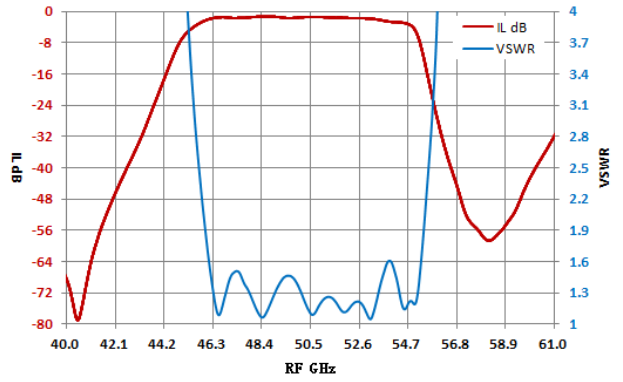


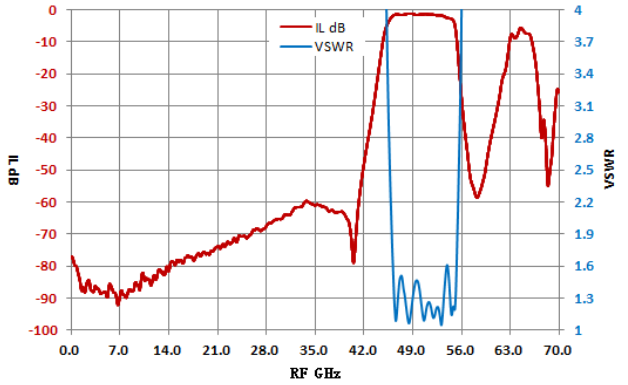
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

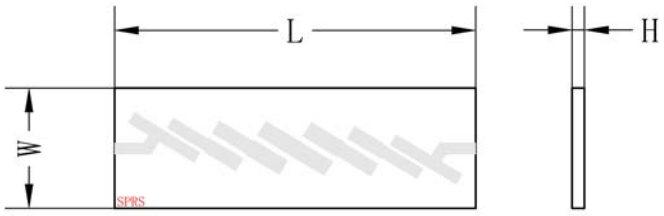
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	48.0	GHz
工作带宽	47.0-49.0	GHz
中心损耗	3.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	30@DC-44.0GHz	dBc
带外抑制	30@51.8-63.0GHz	dBc

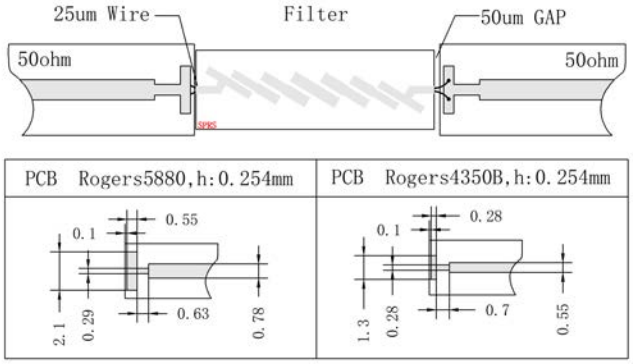
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：6.0，W：1.8，h：0.13

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.87mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

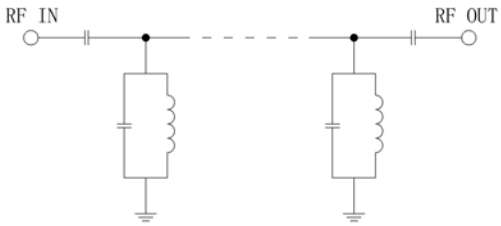
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

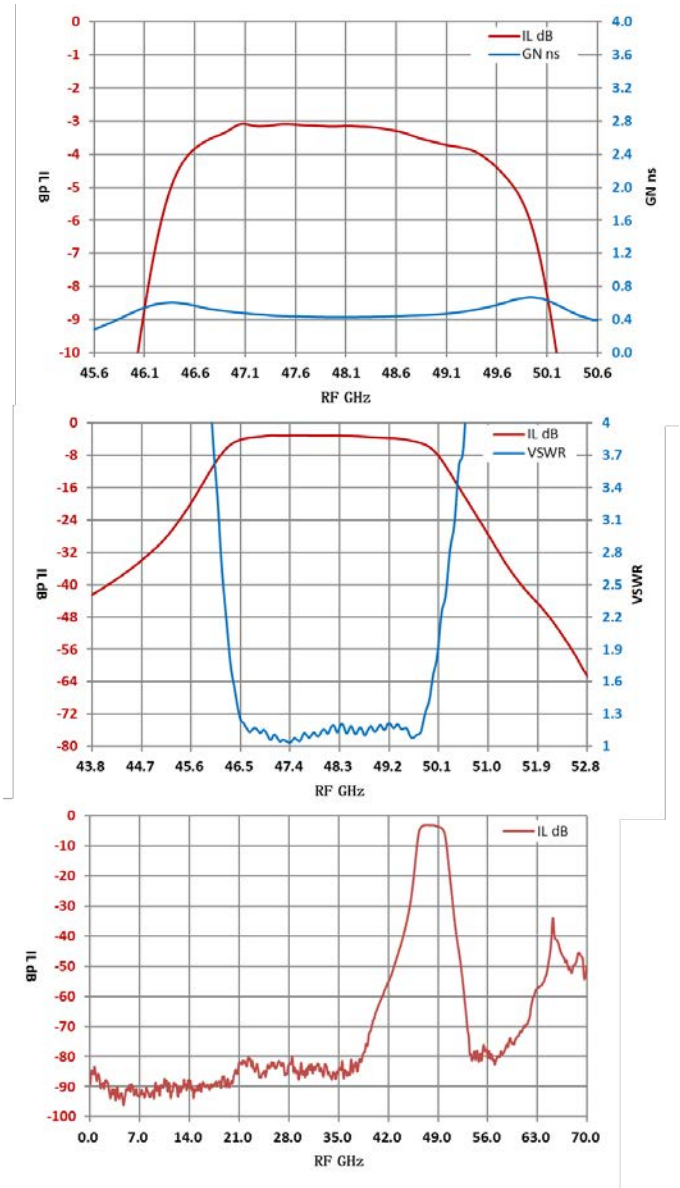
参考图



原理图



典型曲线



产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

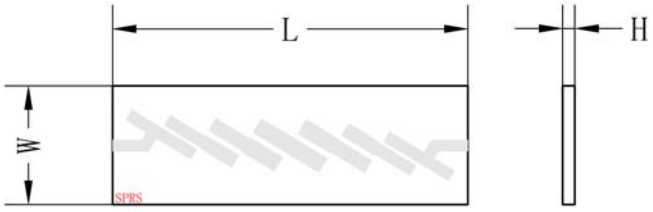
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	50.8	GHz
工作带宽	48.4-53.2	GHz
中心损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-35.0GHz	dBc
带外抑制	40@59.2-63.0GHz	dBc

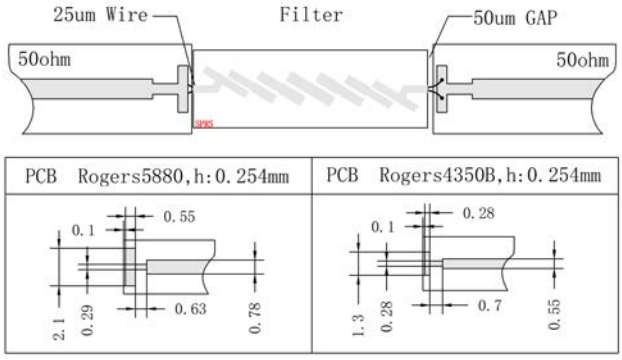
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：4.0，W：1.8，h：0.13

外形图：端口居中



推荐装配图



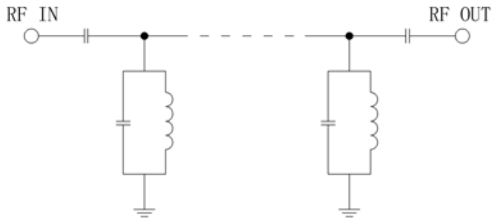
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.37mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

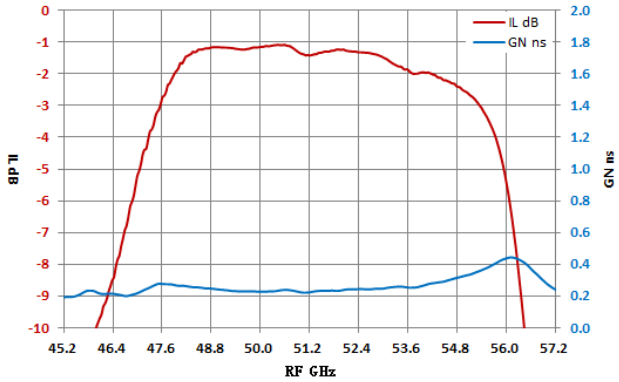
参考实物图

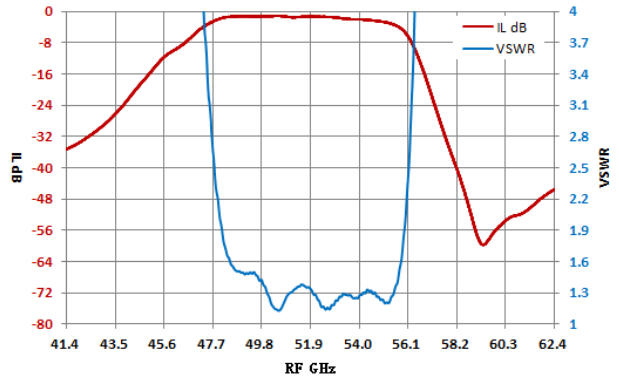


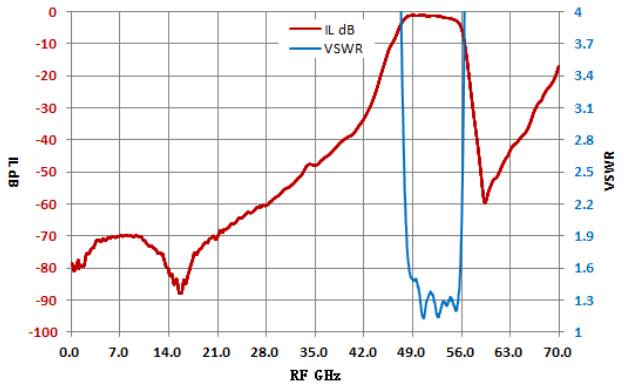
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

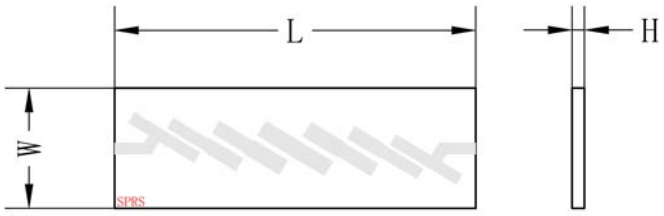
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	54.2	GHz
工作带宽	49.7-58.7	GHz
中心损耗	3.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.2	ns
带外抑制	40@DC-44.9GHz	dBc
带外抑制	40@65.2-68.0GHz	dBc

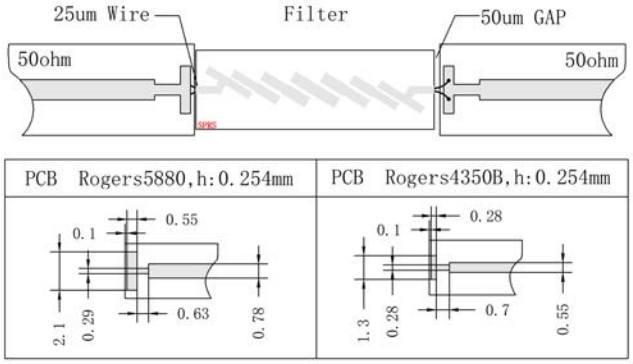
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：5.5，W：1.6，h：0.13

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.87mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

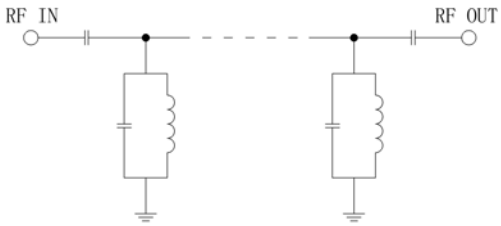
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

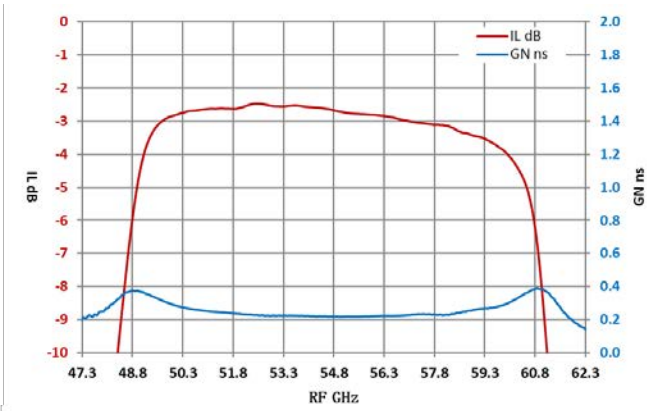
参考图

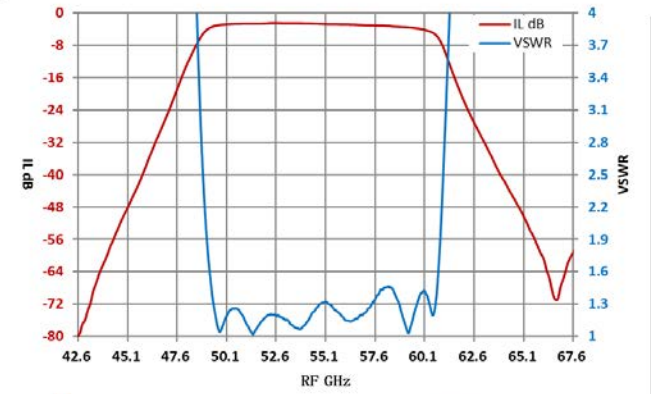


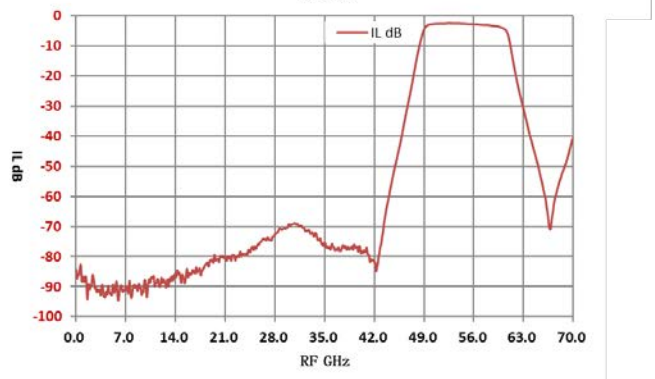
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

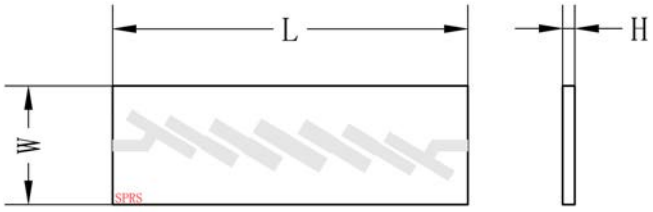
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	50.9	GHz
工作带宽	50.2-51.6	GHz
中心损耗	2.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-39.0GHz	dBc
带外抑制	40@54.9-65.0GHz	dBc

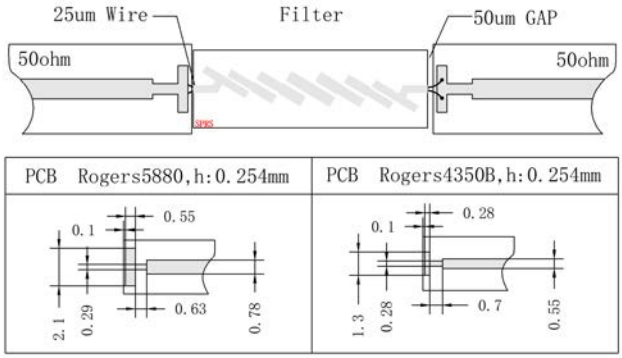
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



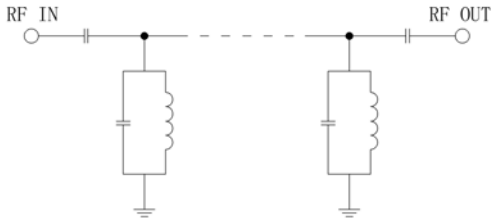
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

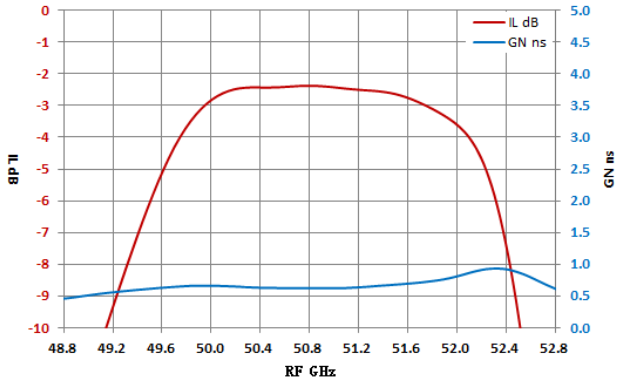
参考实物图

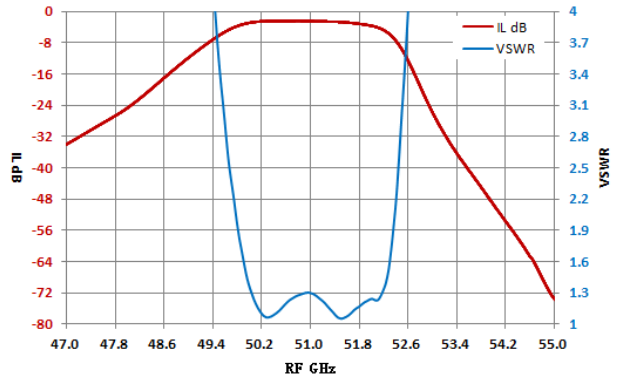


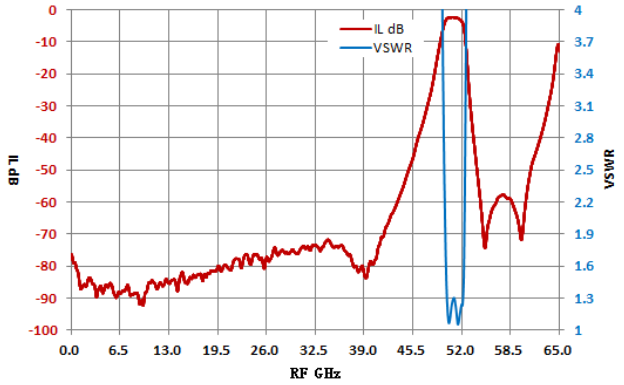
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

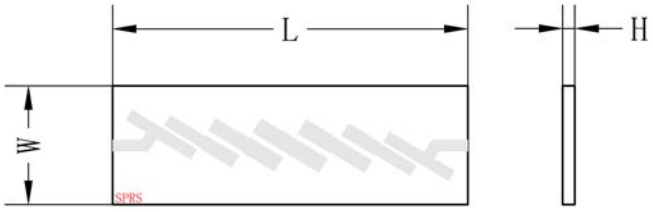
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	60.1	GHz
工作带宽	57.8-62.4	GHz
中心损耗	2.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-53.0GHz	dBc
带外抑制	40@69.0-70.0GHz	dBc

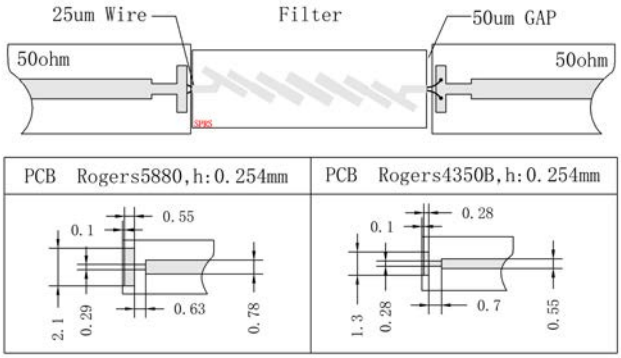
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：1.8，h：0.23

外形图：端口居中



推荐装配图



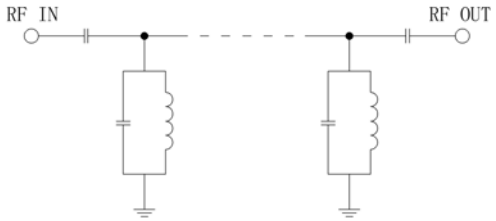
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.87mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

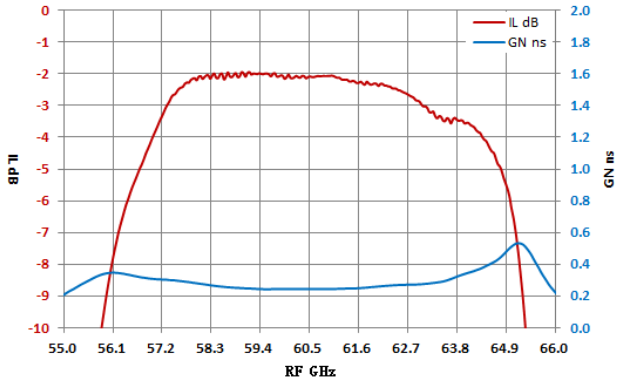
参考实物图

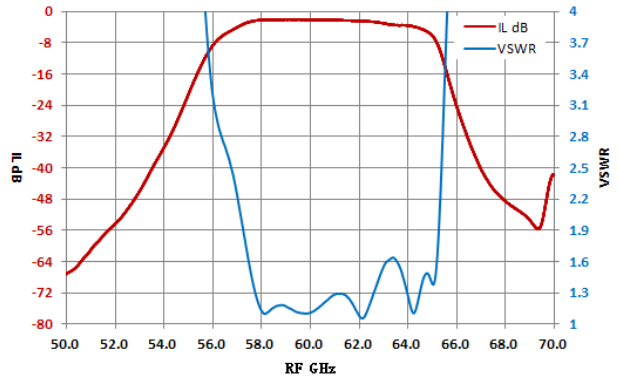


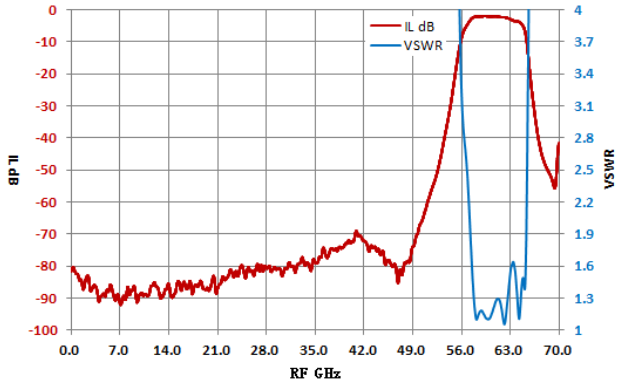
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



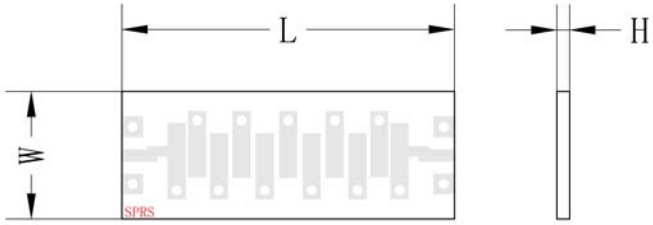
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	10.25	GHz
工作带宽	6.0-14.5	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-3.9GHz	dBc

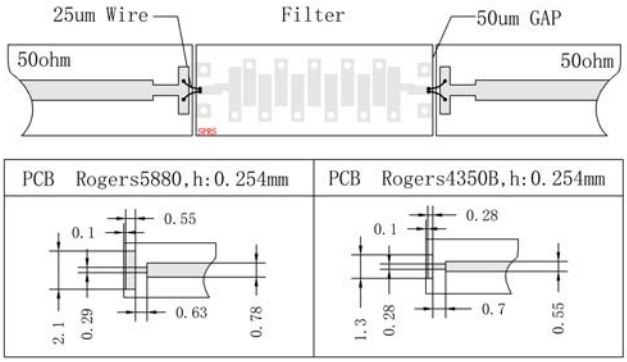
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：4.5，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



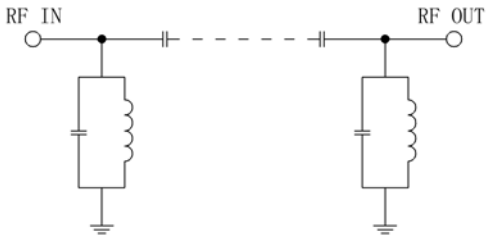
推荐装配图



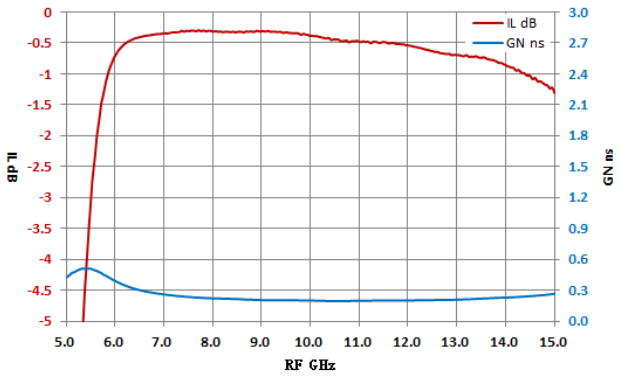
注意事项

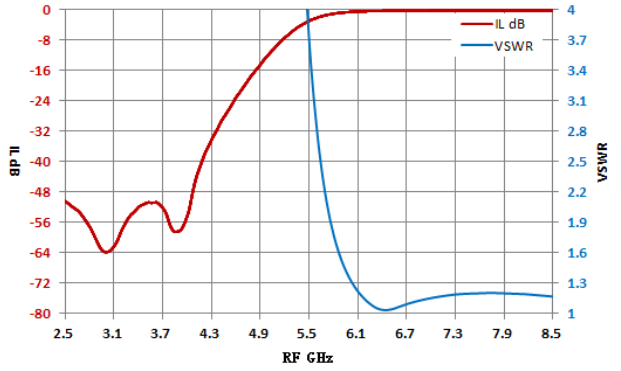
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

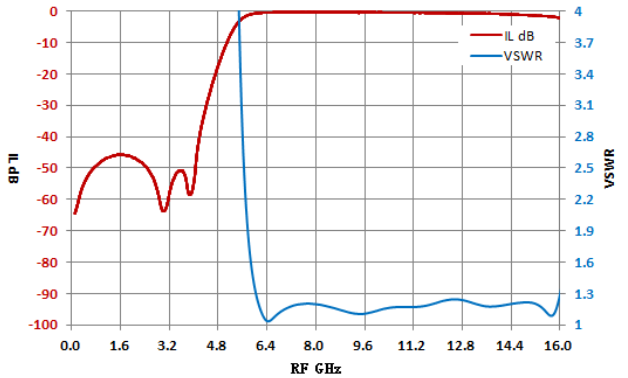
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

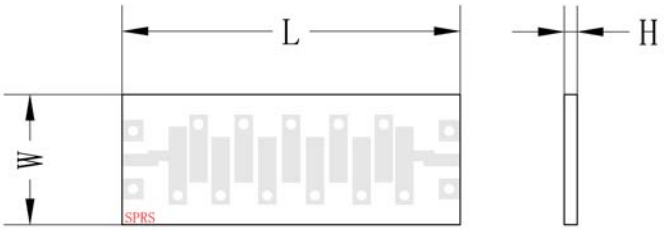
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	12.0	GHz
工作带宽	6.0-18.0	GHz
通带损耗	2.5	dB
带内波动	2.0	dB
驻波比	1.8:1	
群时延波动	0.6	ns
带外抑制	50@DC-4.4GHz	dBc

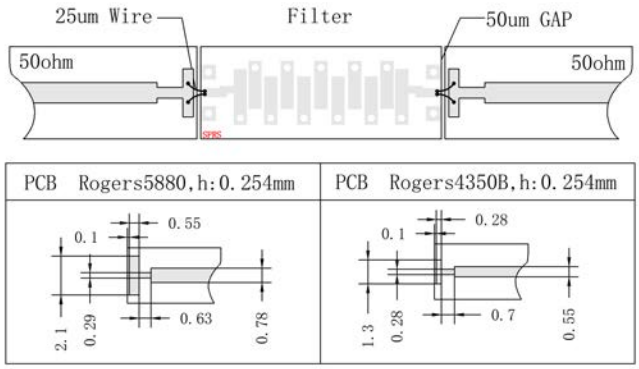
其它要求：设计保证

承受功率	0.5W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：8.0，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

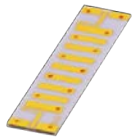
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

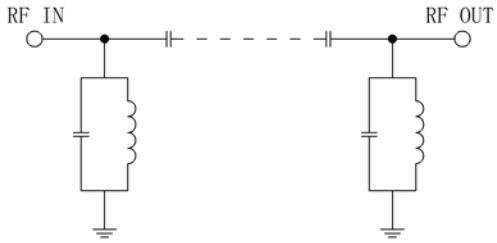
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

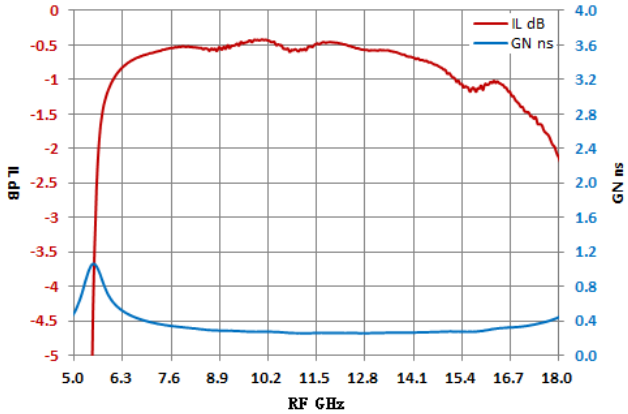
参考图

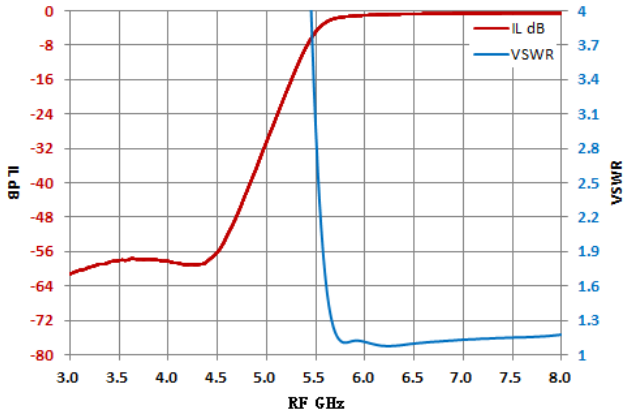


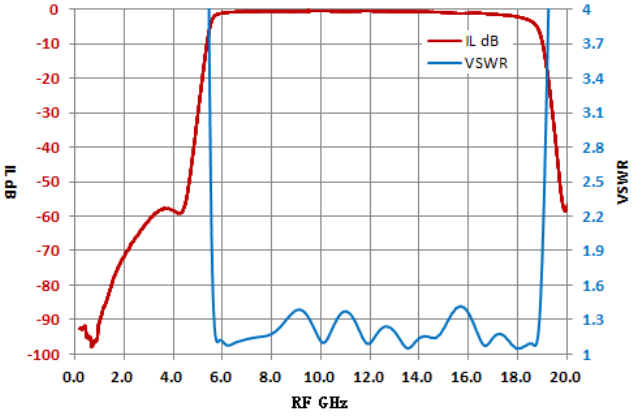
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



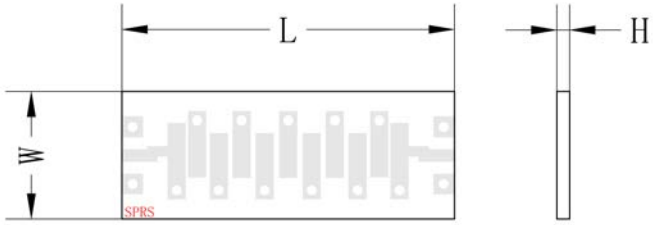
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.6	GHz
工作带宽	6.2-13.0	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-4.8GHz	dBc

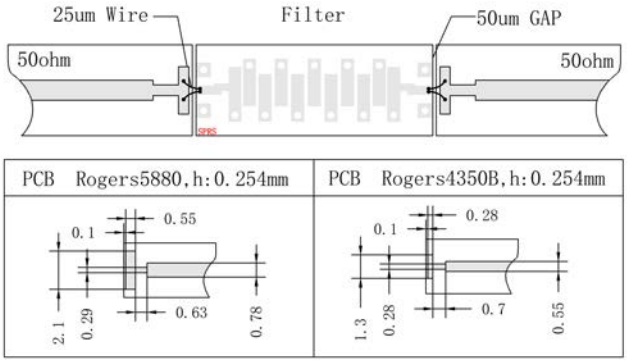
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：2.8，h：0.26

外形图：端口居中



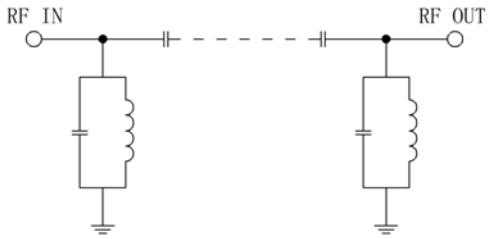
推荐装配图



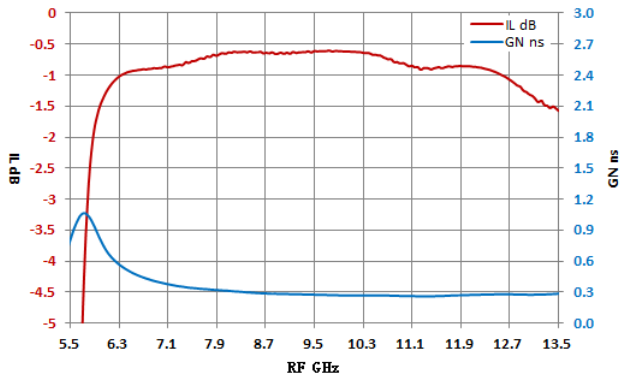
注意事项

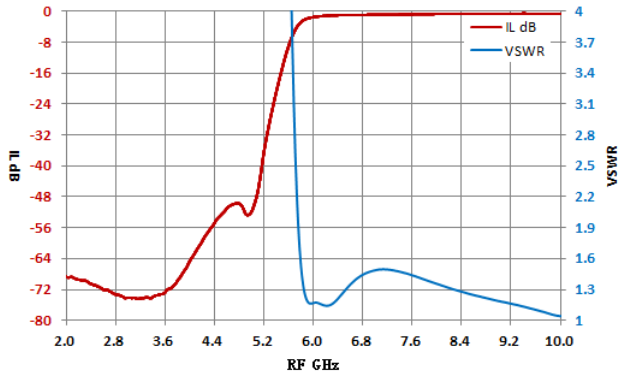
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

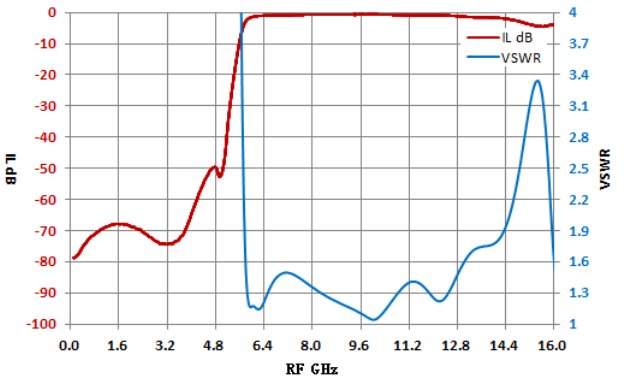
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

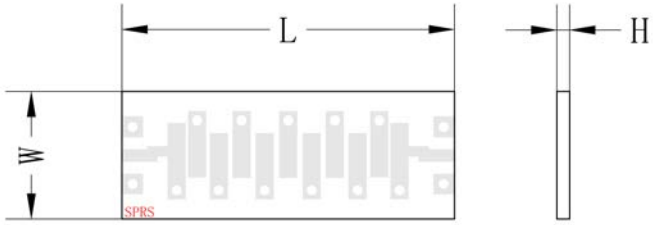
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	12.5	GHz
工作带宽	6.5-18.5	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-4.6GHz	dBc

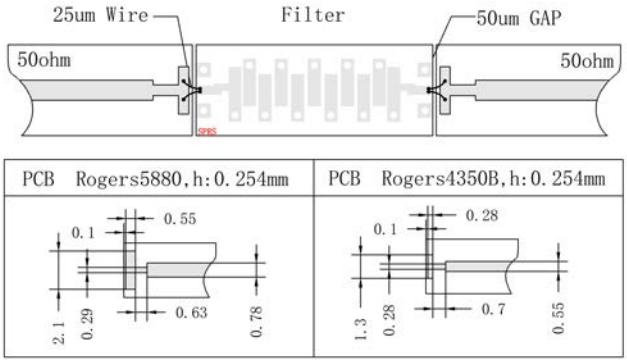
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.5，W：5.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



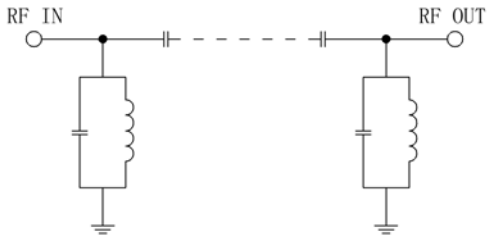
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

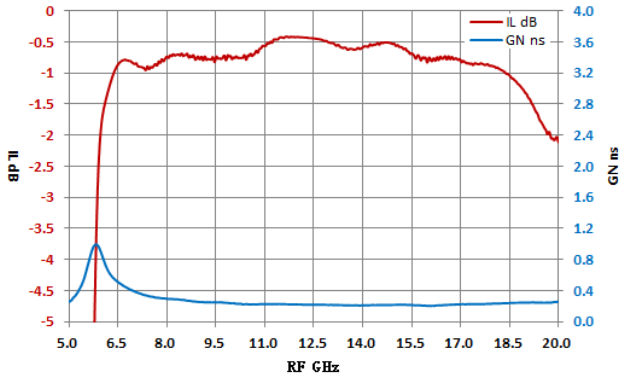
参考实物图

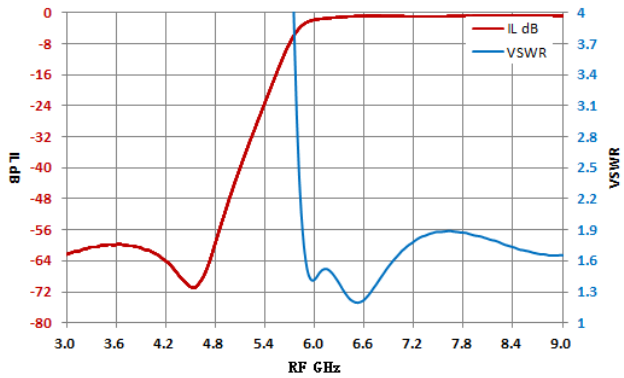


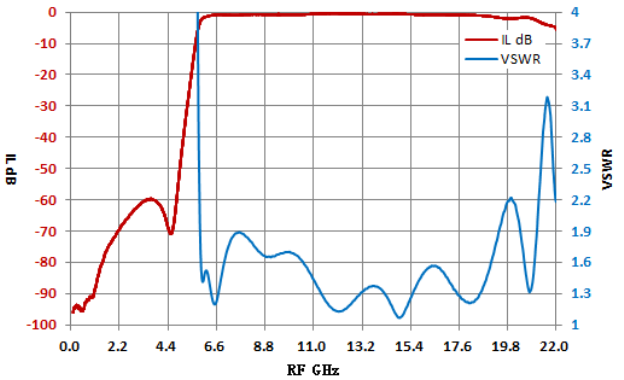
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

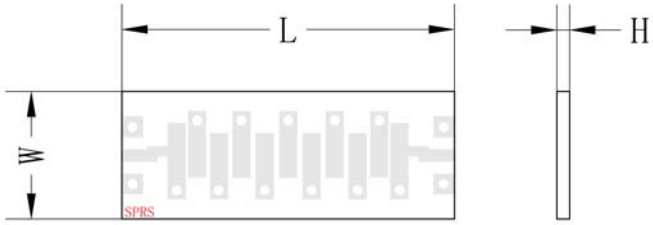
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	12.25	GHz
工作带宽	7.0-17.5	GHz
通带损耗	1.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-4.7GHz	dBc

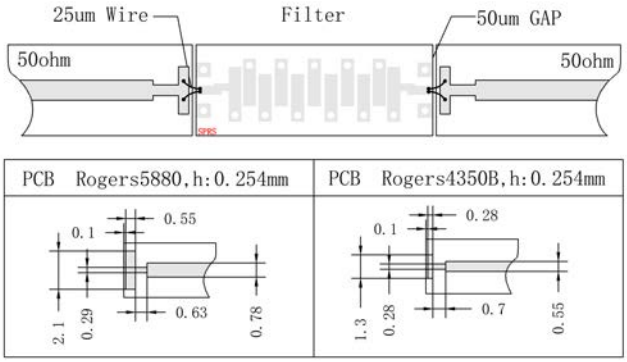
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：4.5，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



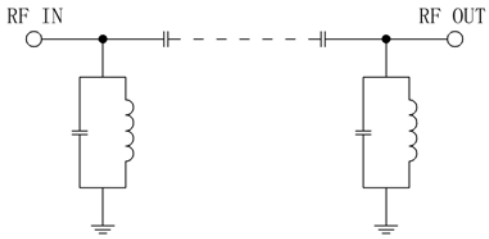
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

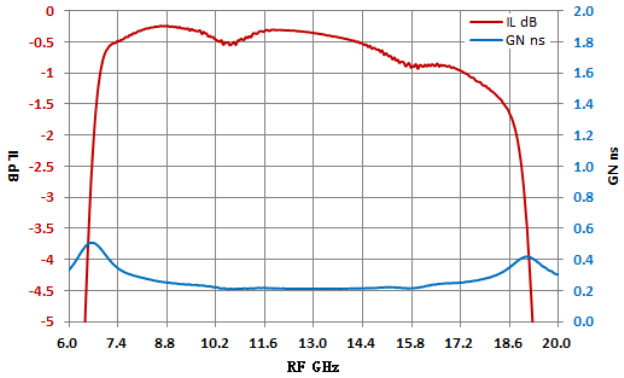
参考实物图

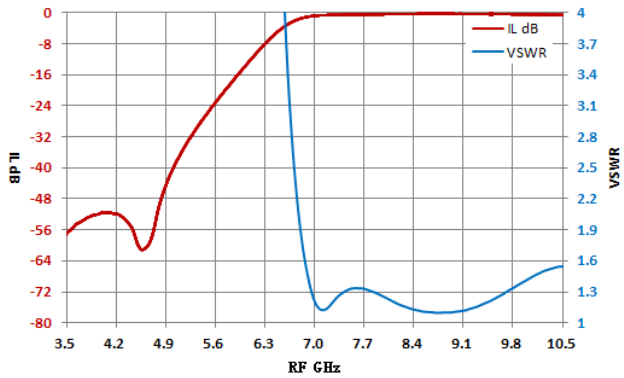


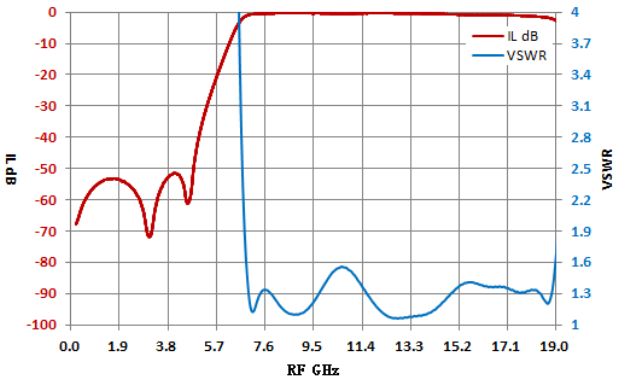
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

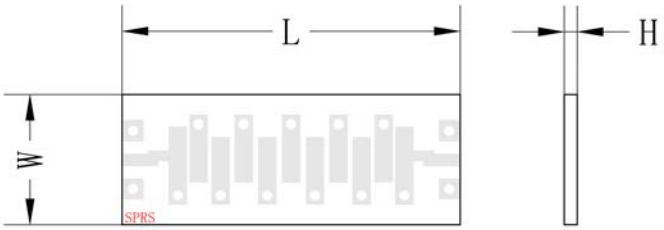
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	13.75	GHz
工作带宽	7.0-20.5	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.8:1	
群时延波动	0.6	ns
带外抑制	50@DC-4.8GHz	dBc

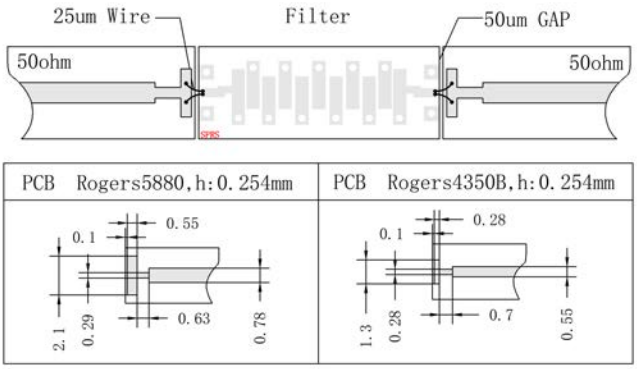
其它要求：设计保证

承受功率	0.5W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：7.0，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

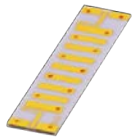
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

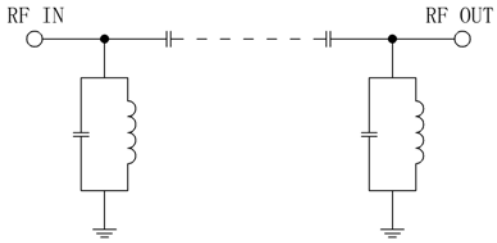
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

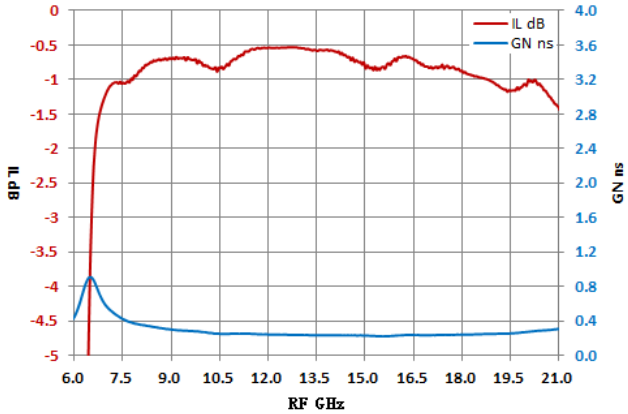
参考图

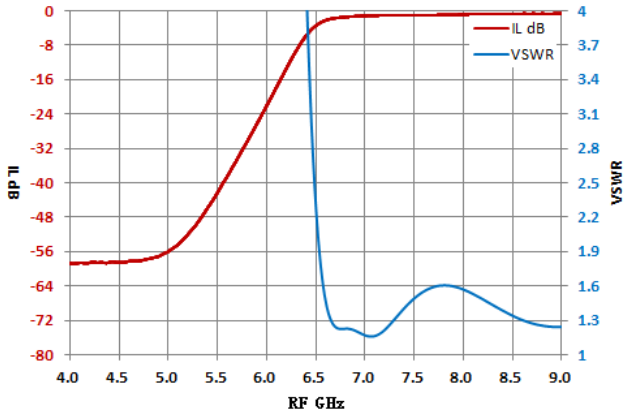


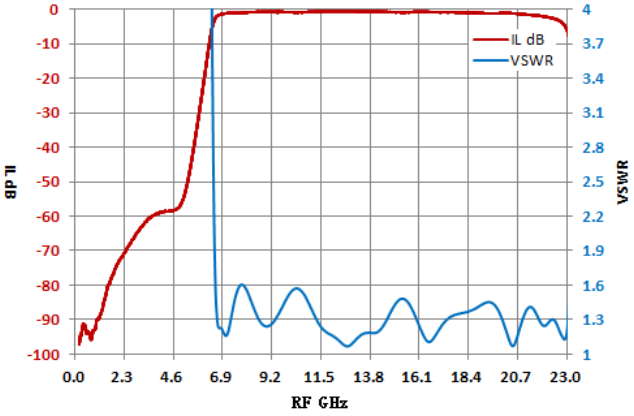
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



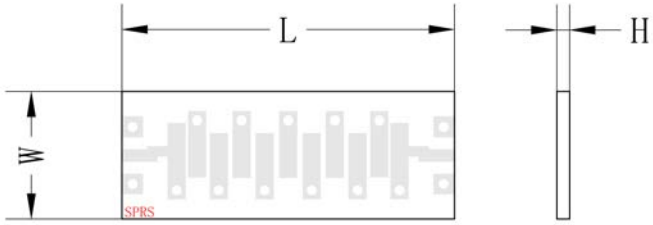
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	13.5	GHz
工作带宽	8.0-19.0	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-5.6GHz	dBc

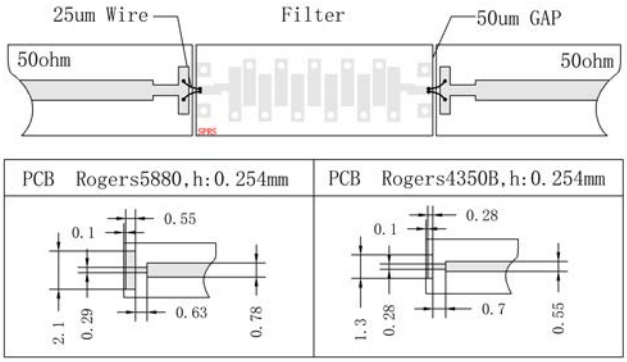
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：4.5，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



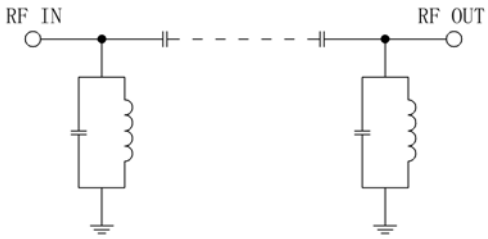
推荐装配图



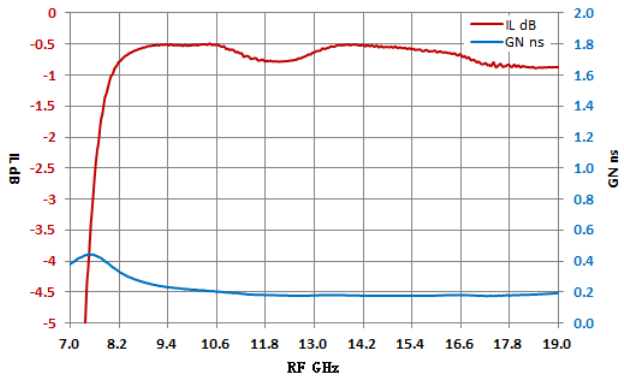
注意事项

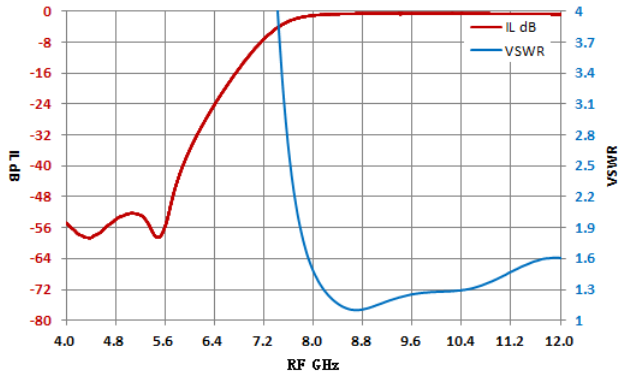
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

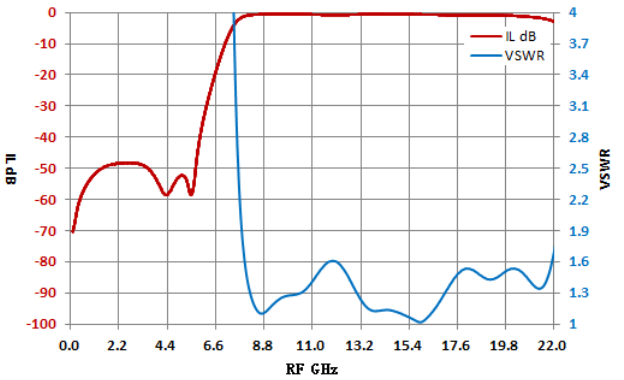
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

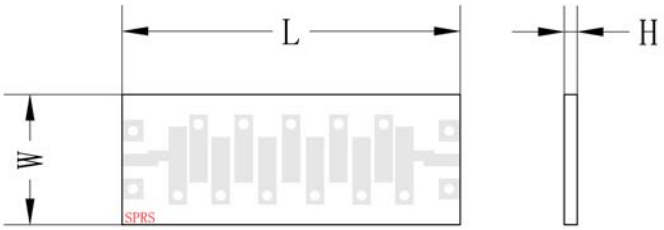
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	15.25	GHz
工作带宽	8.0-22.5	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.8:1	
群时延波动	0.6	ns
带外抑制	50@DC-5.7GHz	dBc

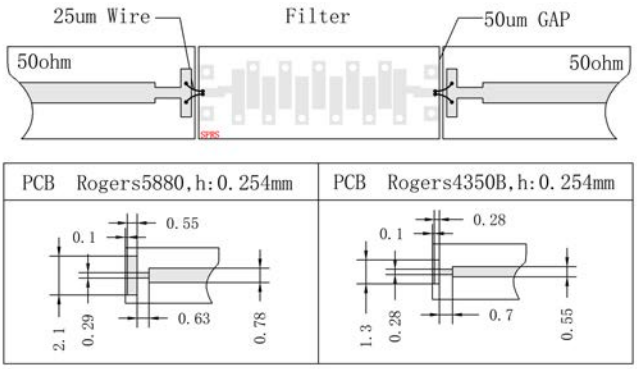
其它要求：设计保证

承受功率	0.5W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：6.5，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

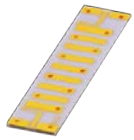
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

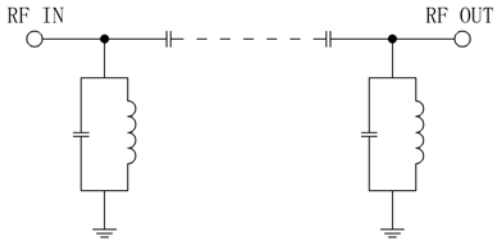
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

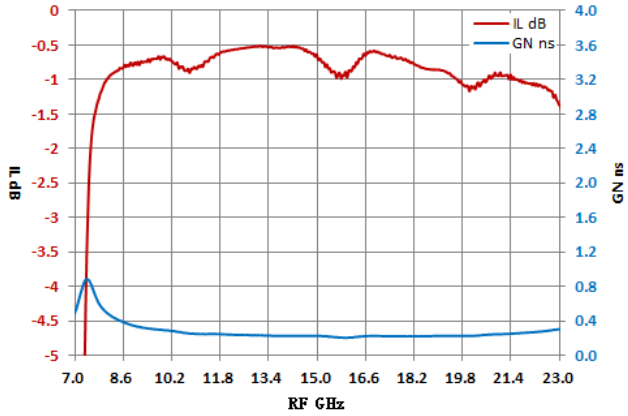
参考图

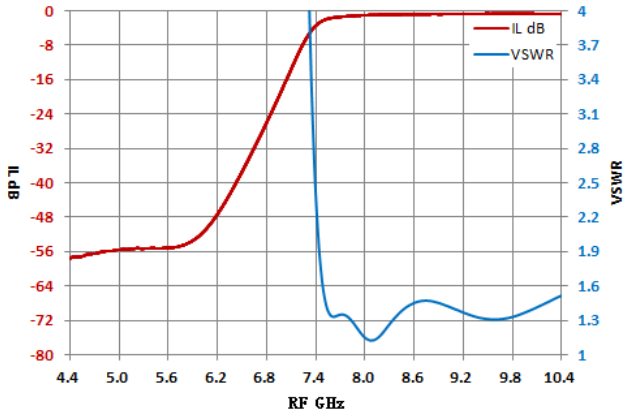


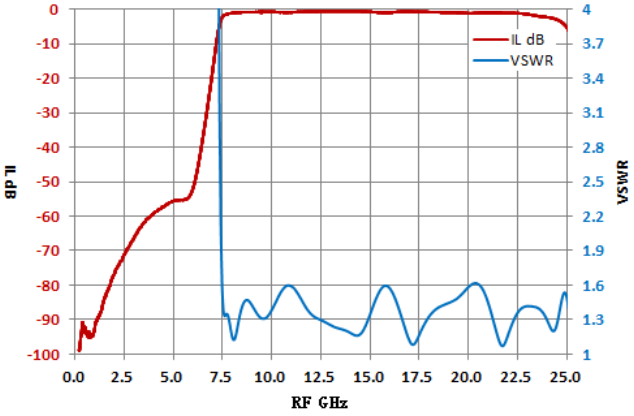
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



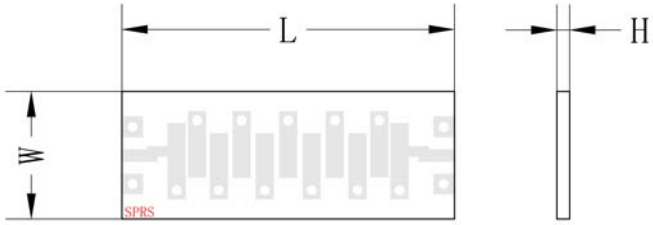
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	15.1	GHz
工作带宽	9.2-21.0	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-6.6GHz	dBc

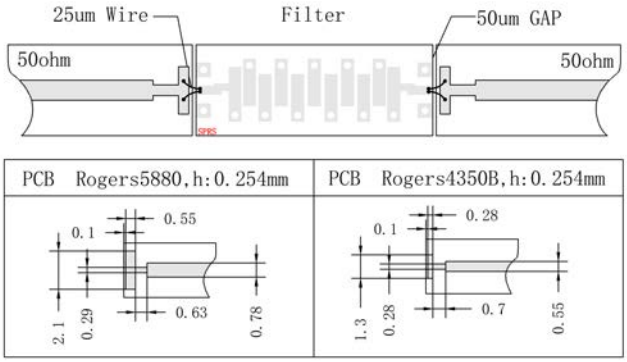
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：3.2，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



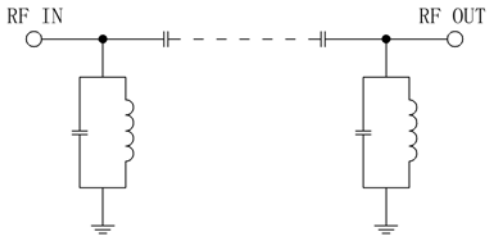
推荐装配图



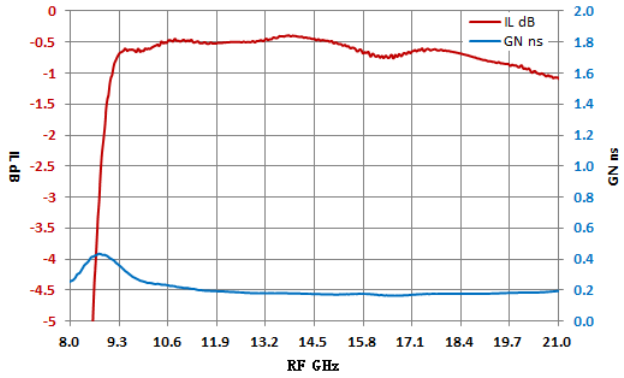
注意事项

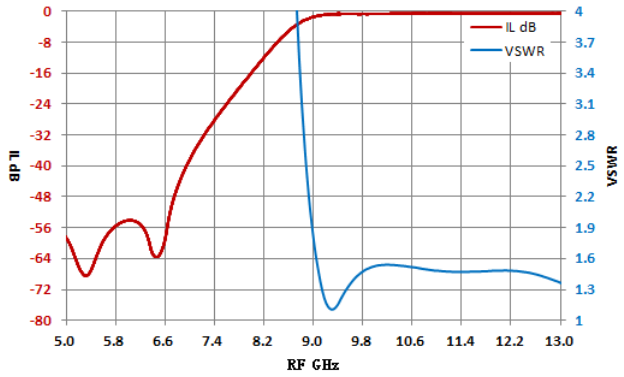
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

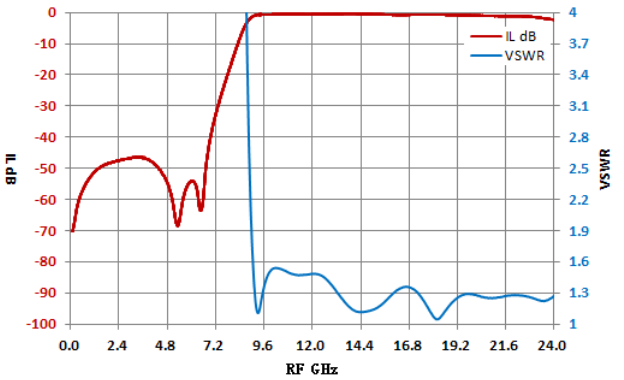
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



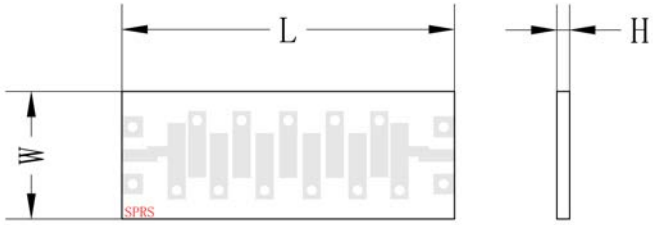
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	16.4	GHz
工作带宽	9.8-23.0	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	30@DC-7.6GHz	dBc

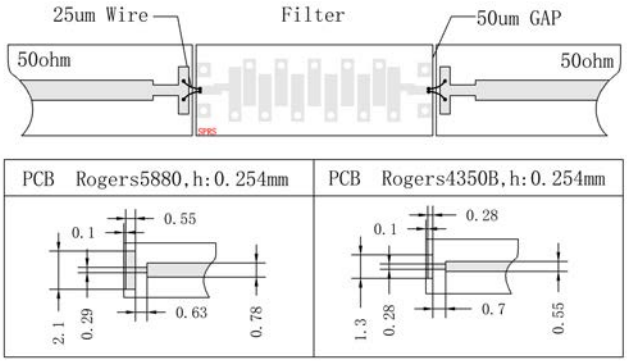
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：3.2，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



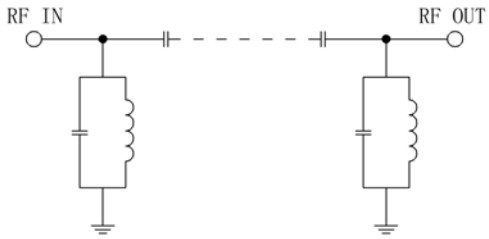
推荐装配图



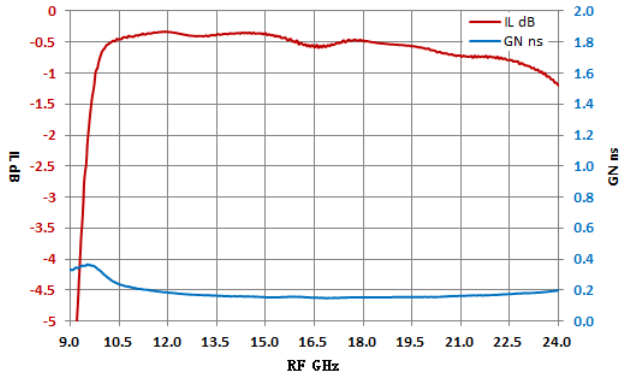
注意事项

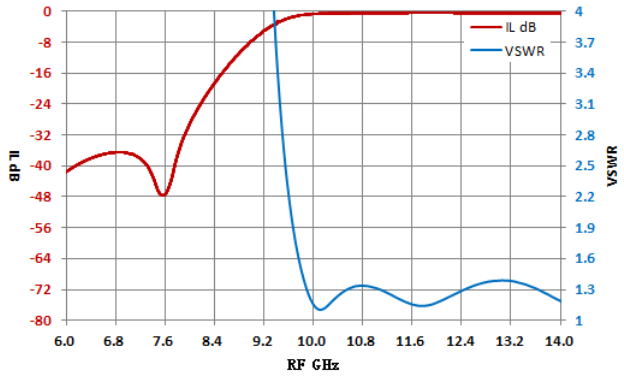
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

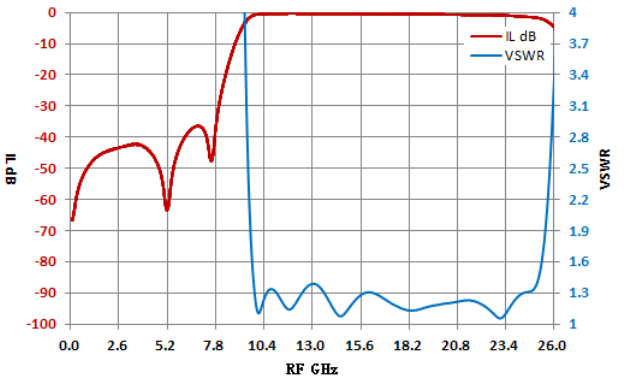
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



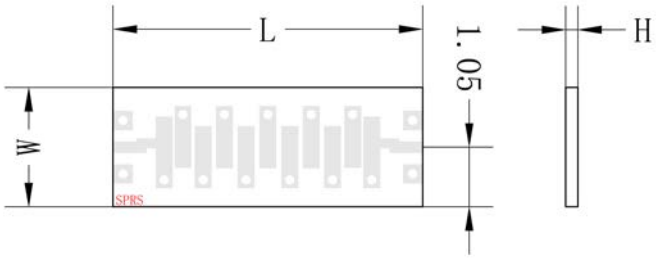
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	17.0	GHz
工作带宽	11.0-23.0	GHz
通带损耗	1.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	25@DC-9.5GHz	dBc

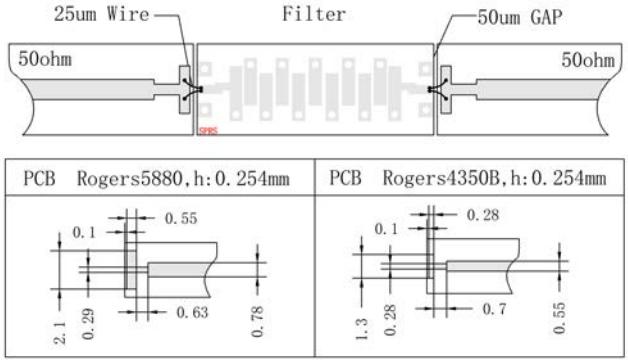
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：5.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



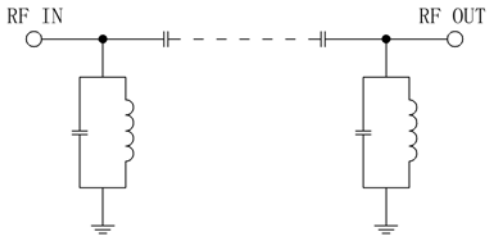
推荐装配图



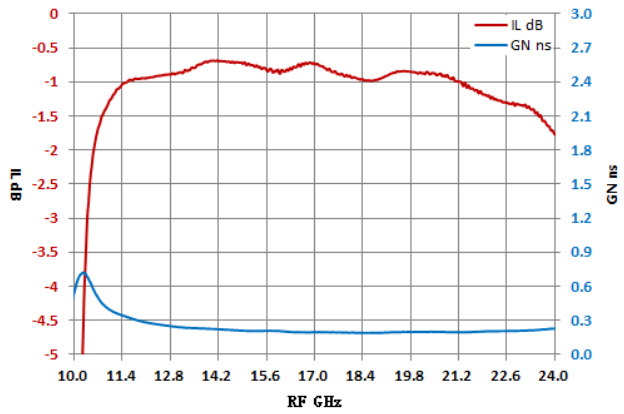
注意事项

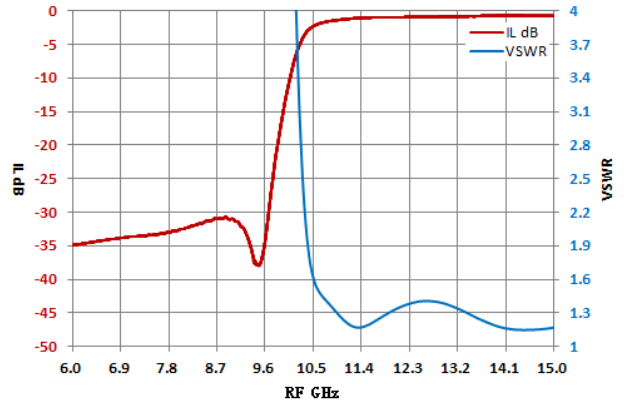
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

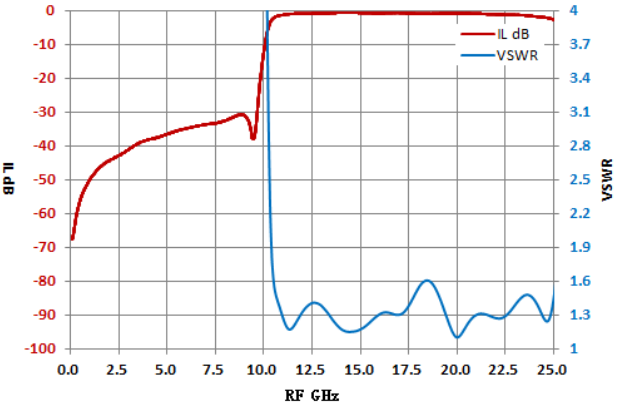
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



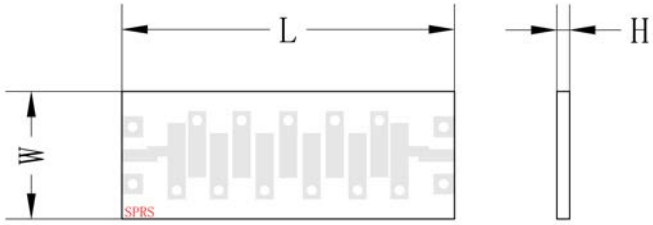
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	19.0	GHz
工作带宽	11.0-27.0	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	30@DC-8.5GHz	dBc

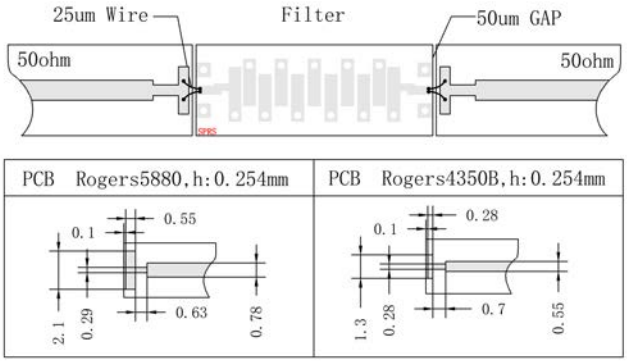
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：3.2，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



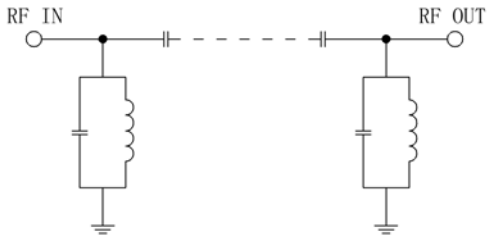
推荐装配图



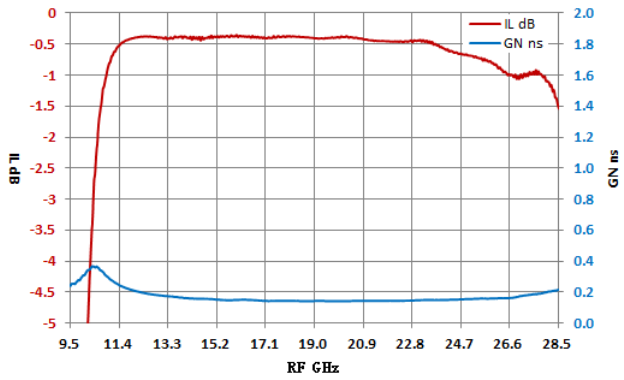
注意事项

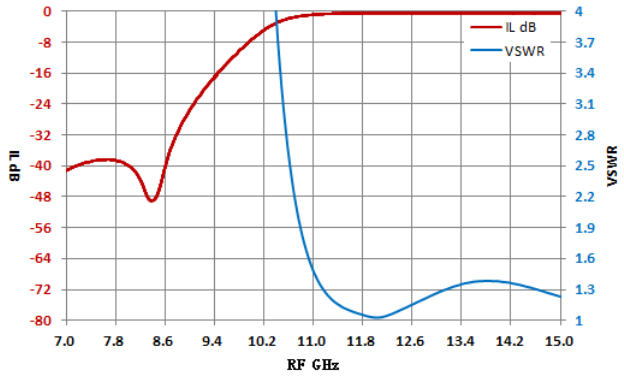
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

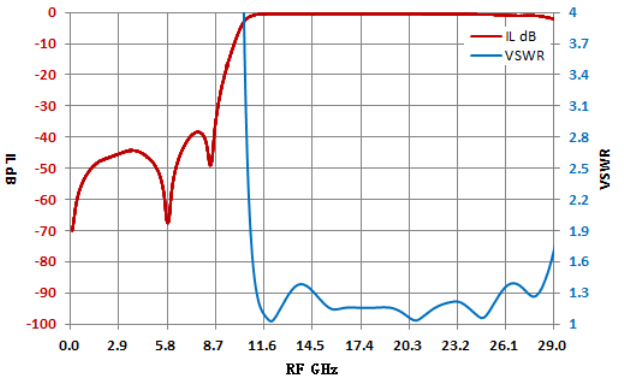
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



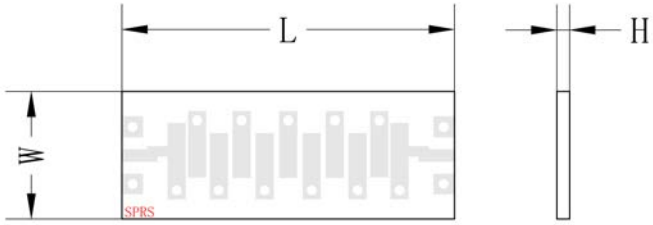
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	19.9	GHz
工作带宽	11.8-28.0	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	28@DC-9.3GHz	dBc

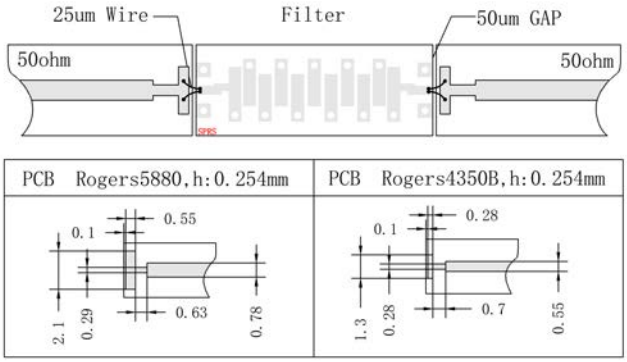
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：3.2，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



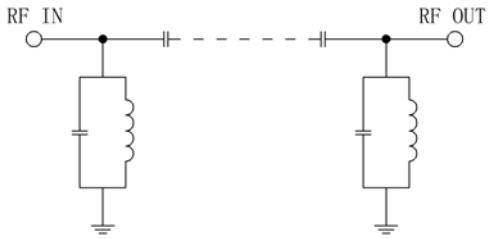
推荐装配图



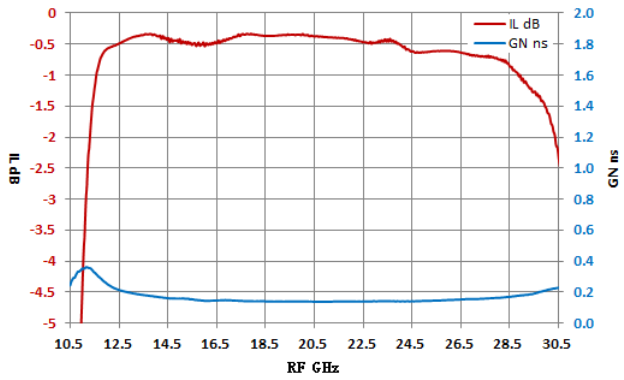
注意事项

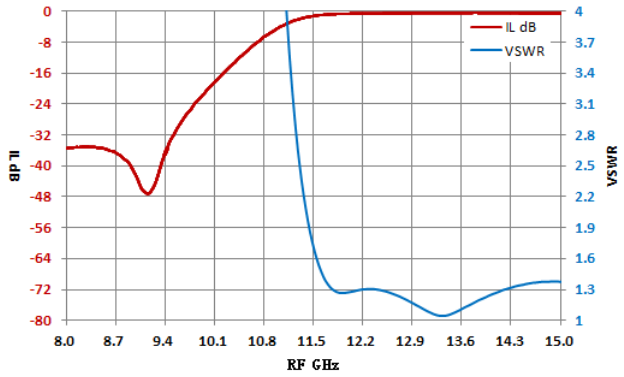
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

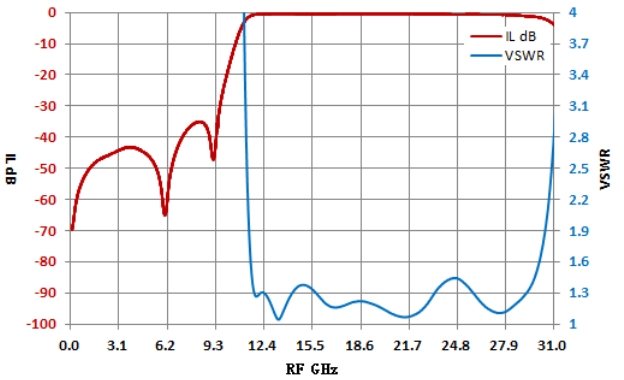
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



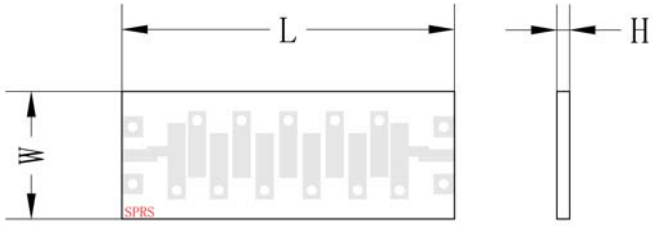
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	20.9	GHz
工作带宽	12.8-29.0	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	28@DC-10.3GHz	dBc

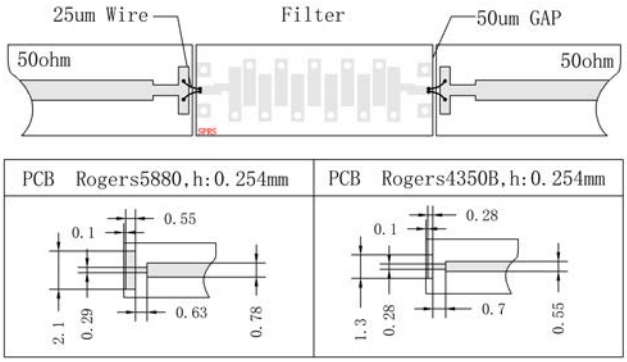
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：3.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



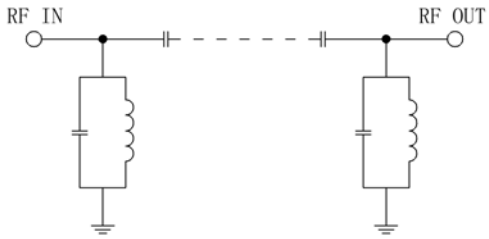
推荐装配图



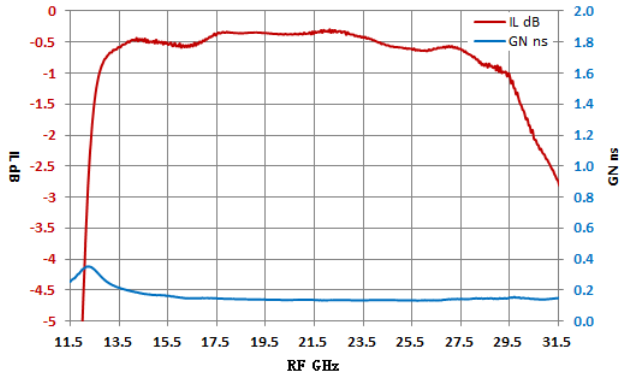
注意事项

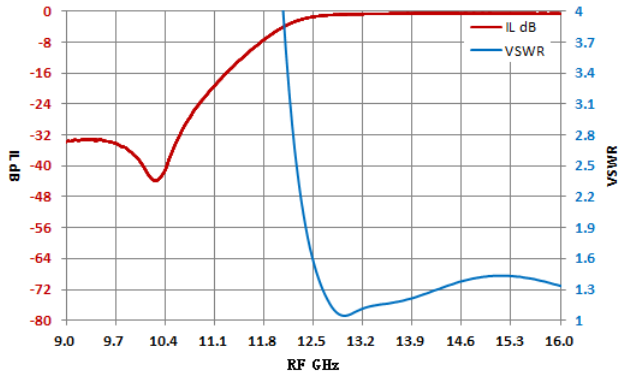
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

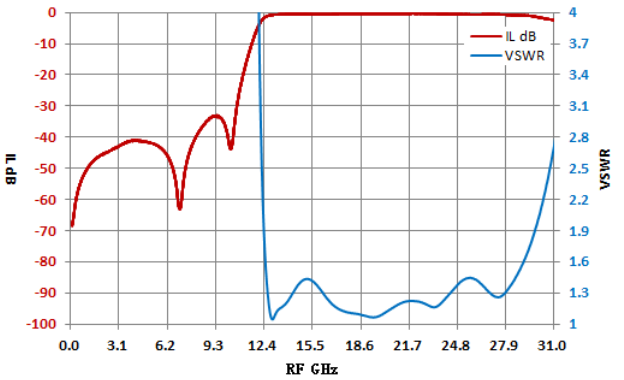
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



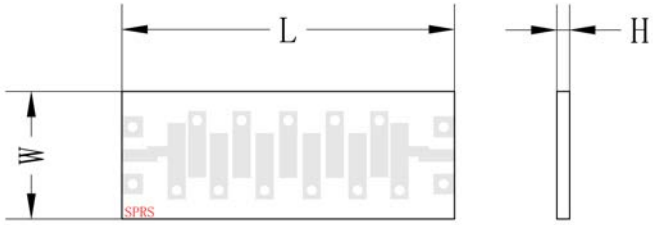
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	22.9	GHz
工作带宽	13.8-32.0	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	28@DC-11.0GHz	dBc

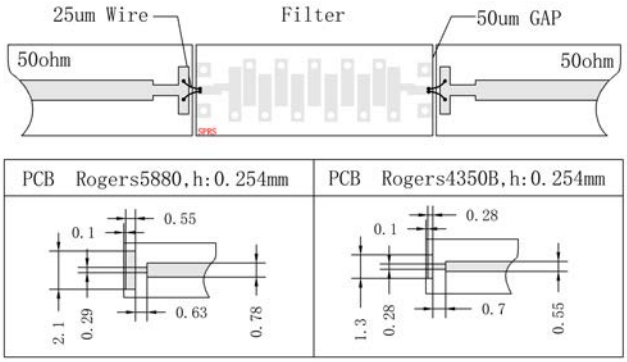
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：3.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



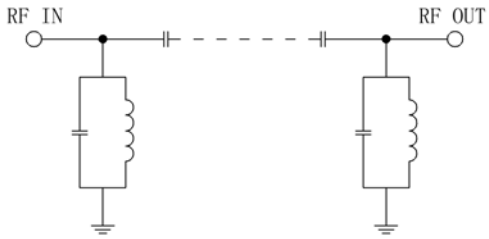
推荐装配图



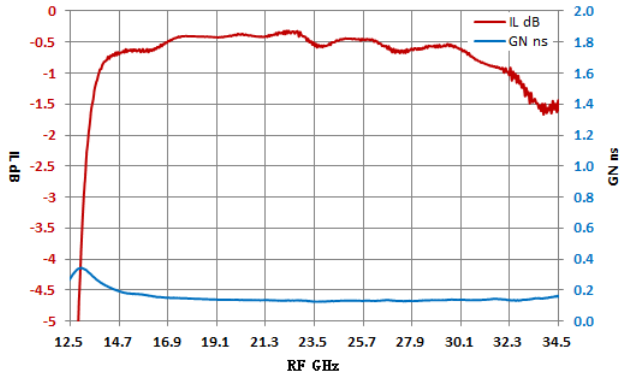
注意事项

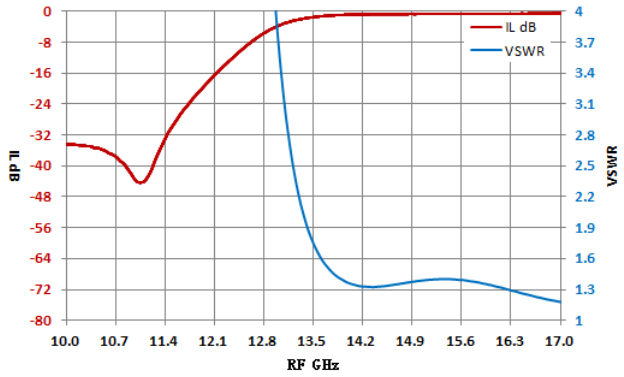
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

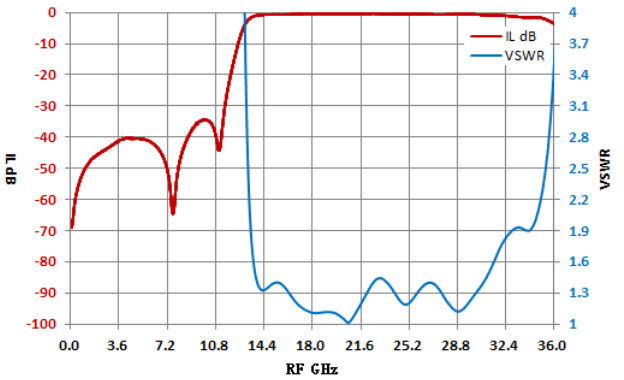
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



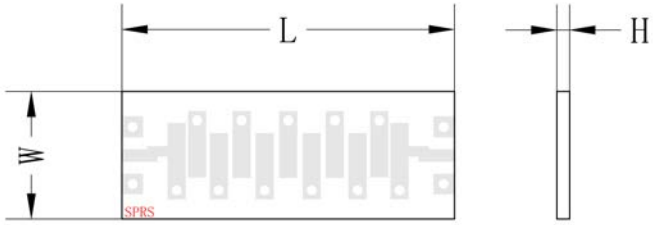
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	24.9	GHz
工作带宽	14.8-35.0	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	28@DC-11.8GHz	dBc

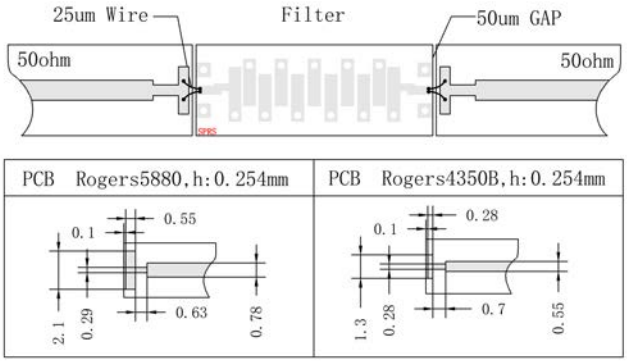
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：3.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



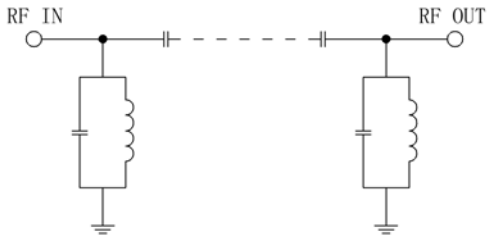
推荐装配图



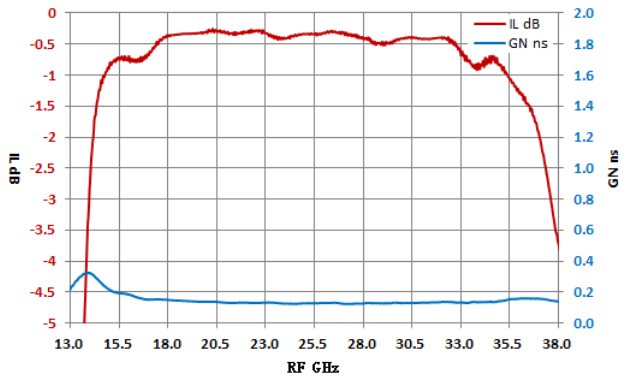
注意事项

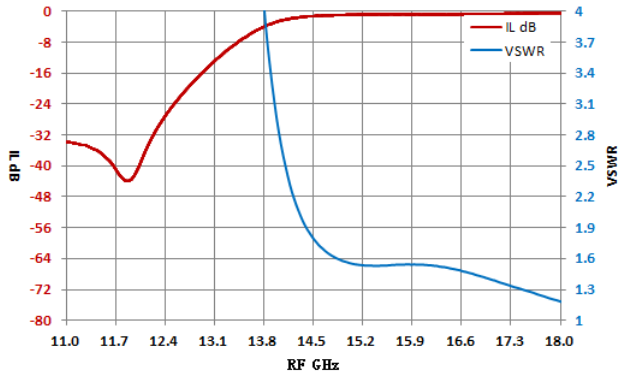
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

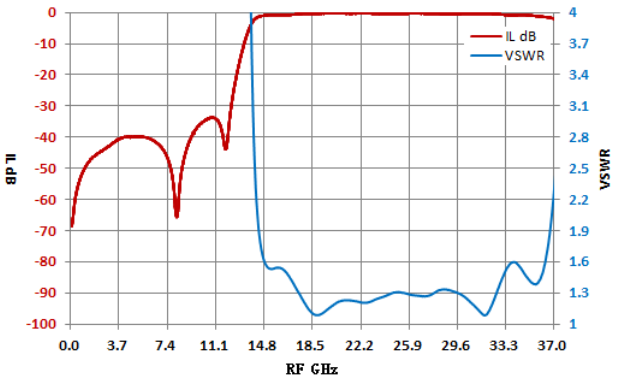
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



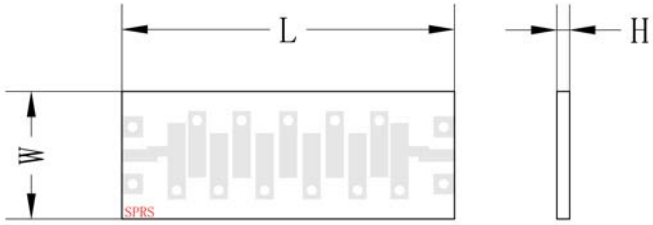
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	26.9	GHz
工作带宽	15.8-38.0	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	28@DC-12.5GHz	dBc

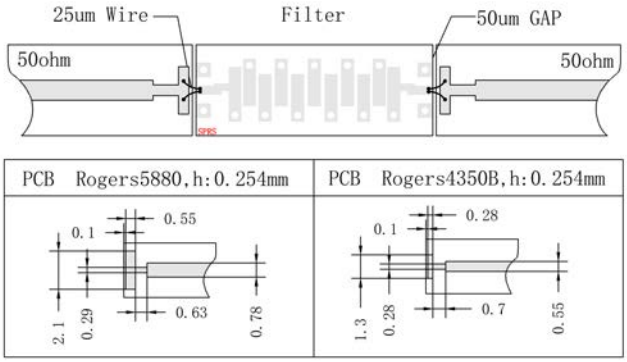
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：3.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



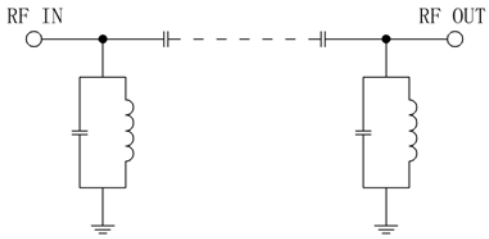
推荐装配图



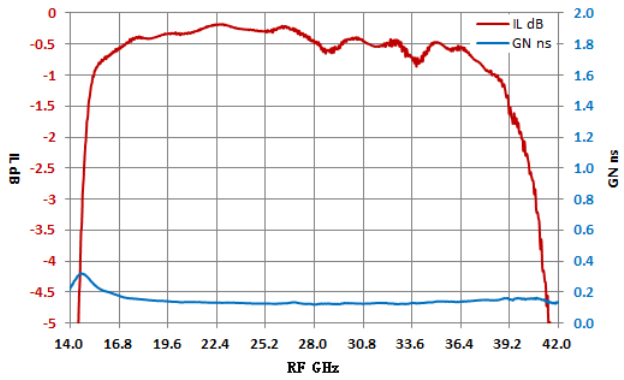
注意事项

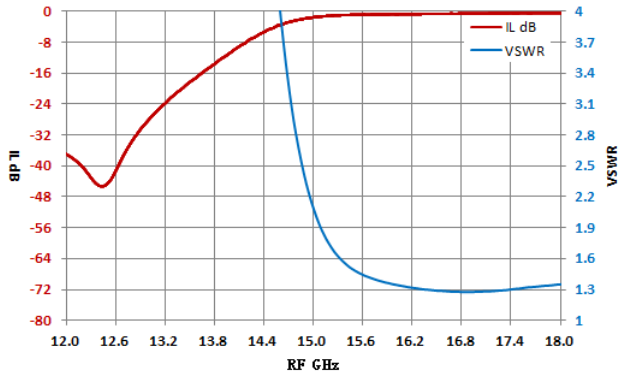
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

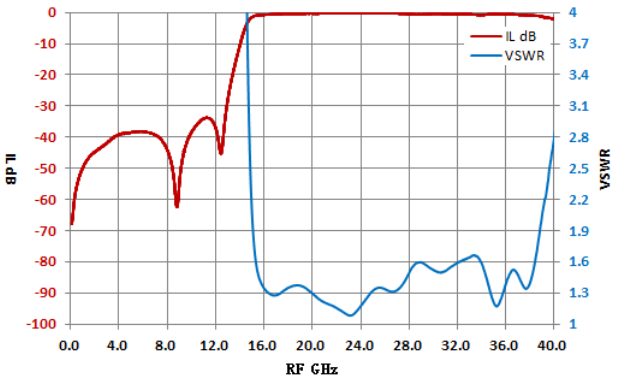
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

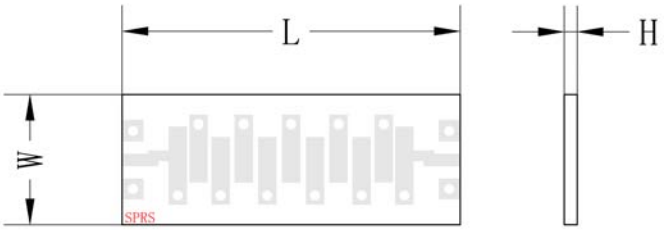
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	33.0	GHz
工作带宽	16.0-50.0	GHz
通带损耗	1.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.2	ns
带外抑制	25@5.0-10.0GHz	dBc
带外抑制	45@DC-5.0GHz	dBc

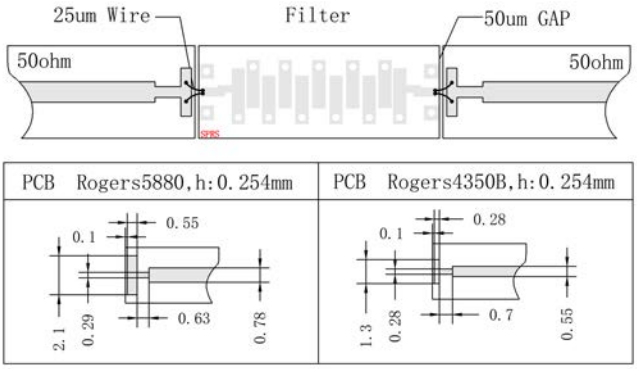
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：7.5，W：2.2，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

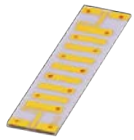
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

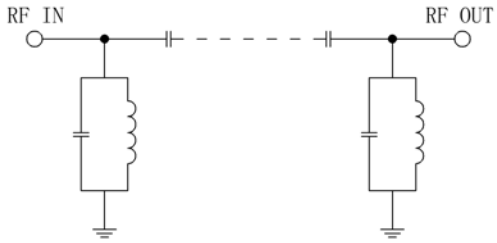
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

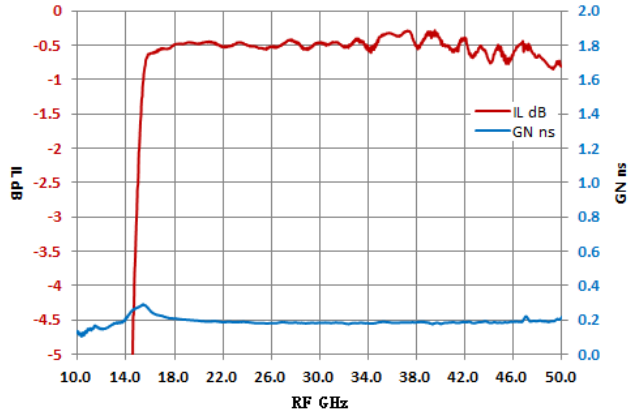
参考图

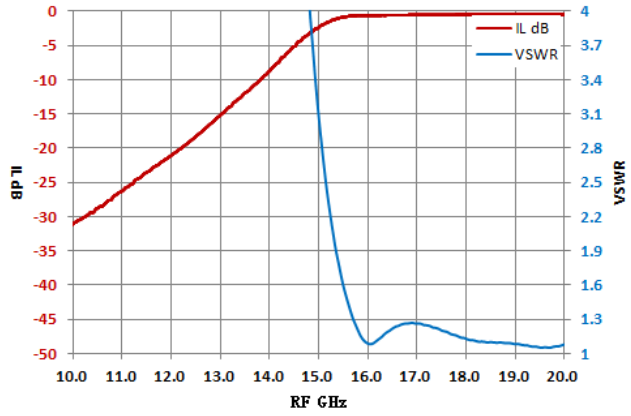


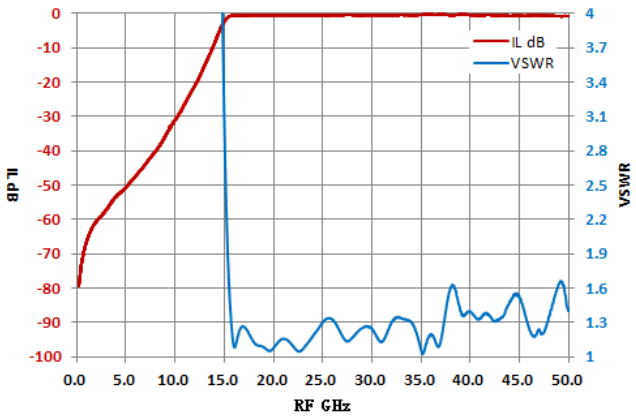
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



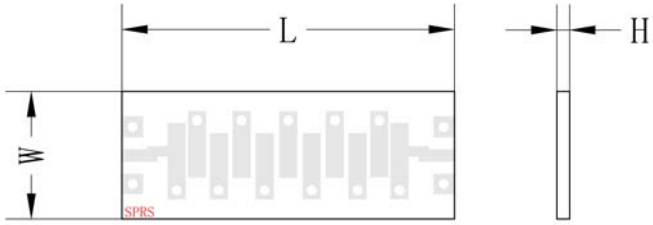
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	27.6	GHz
工作带宽	16.2-39.0	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	25@DC-13.4GHz	dBc

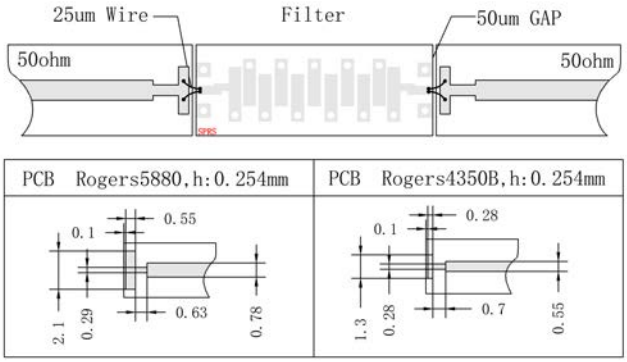
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：3.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



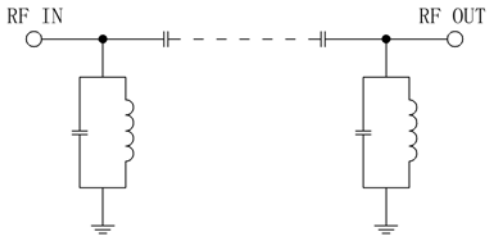
推荐装配图



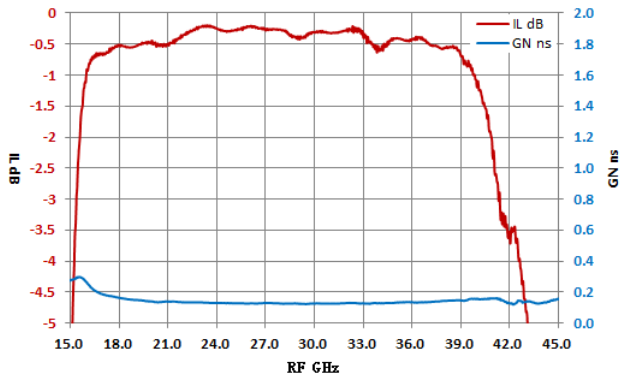
注意事项

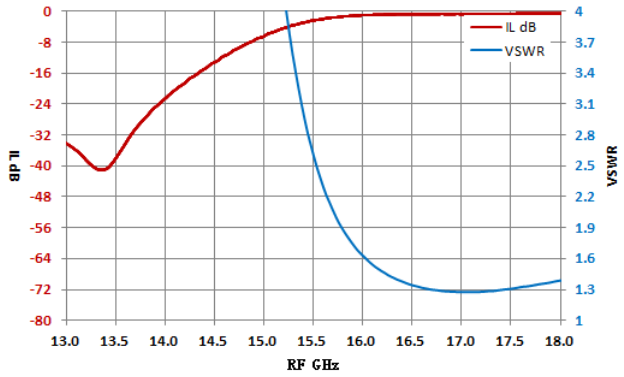
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

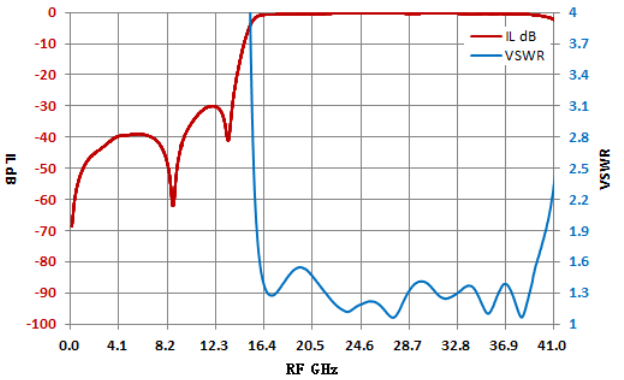
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



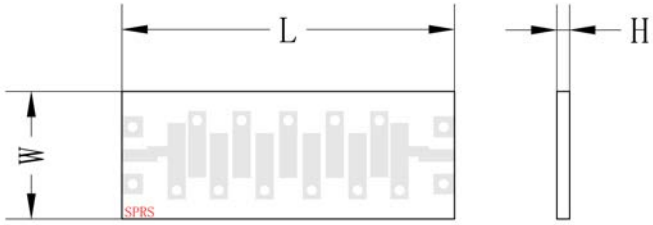
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	28.4	GHz
工作带宽	16.8-40.0	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	28@DC-13.1GHz	dBc

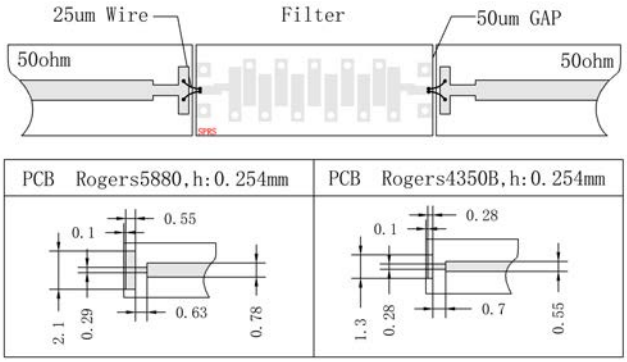
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：3.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



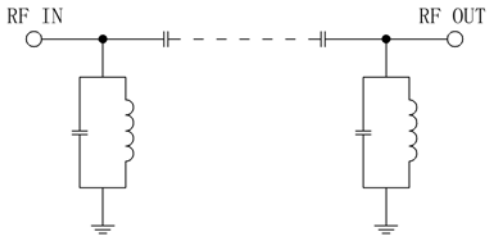
推荐装配图



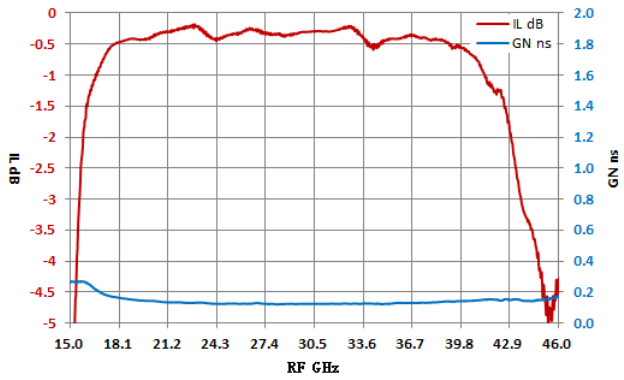
注意事项

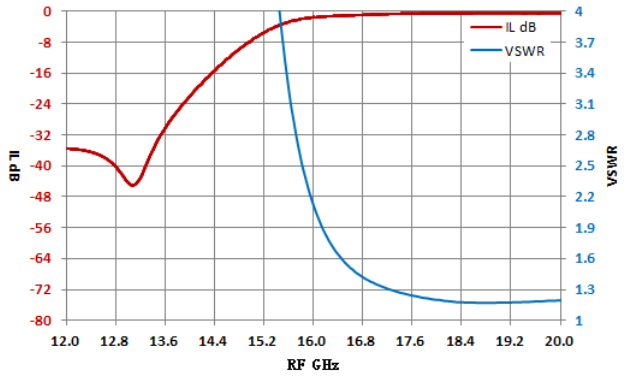
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

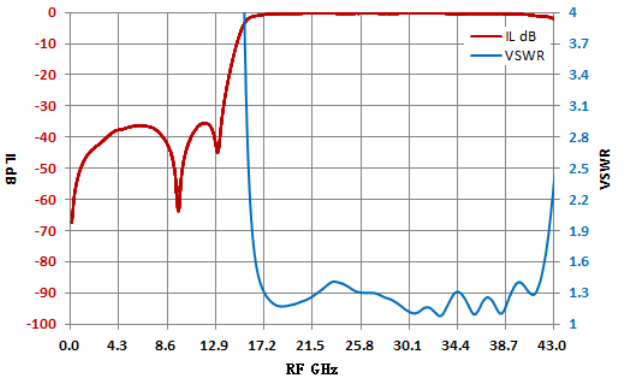
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

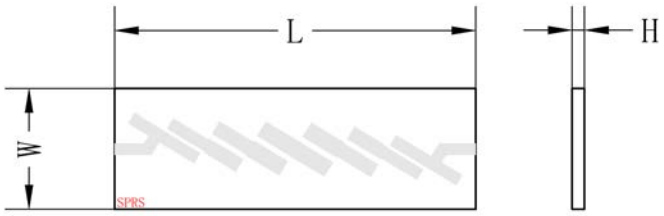
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	31.5	GHz
工作带宽	18.0-45.0	GHz
通带损耗	2.5	dB
带内波动	1.5	dB
驻波比	1.8:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@DC-14.0GHz	dBc

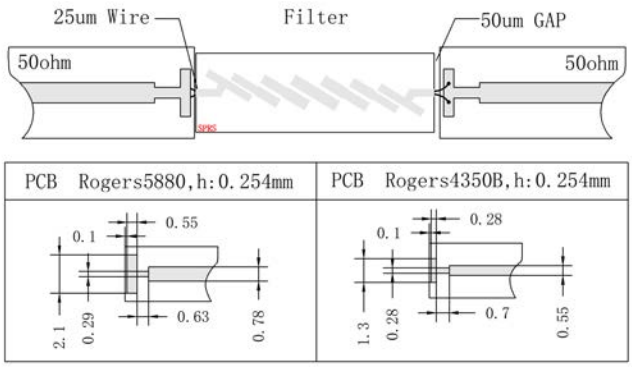
其它要求：设计保证

承受功率	0.5W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：3.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

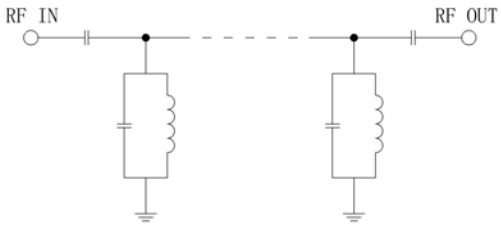
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

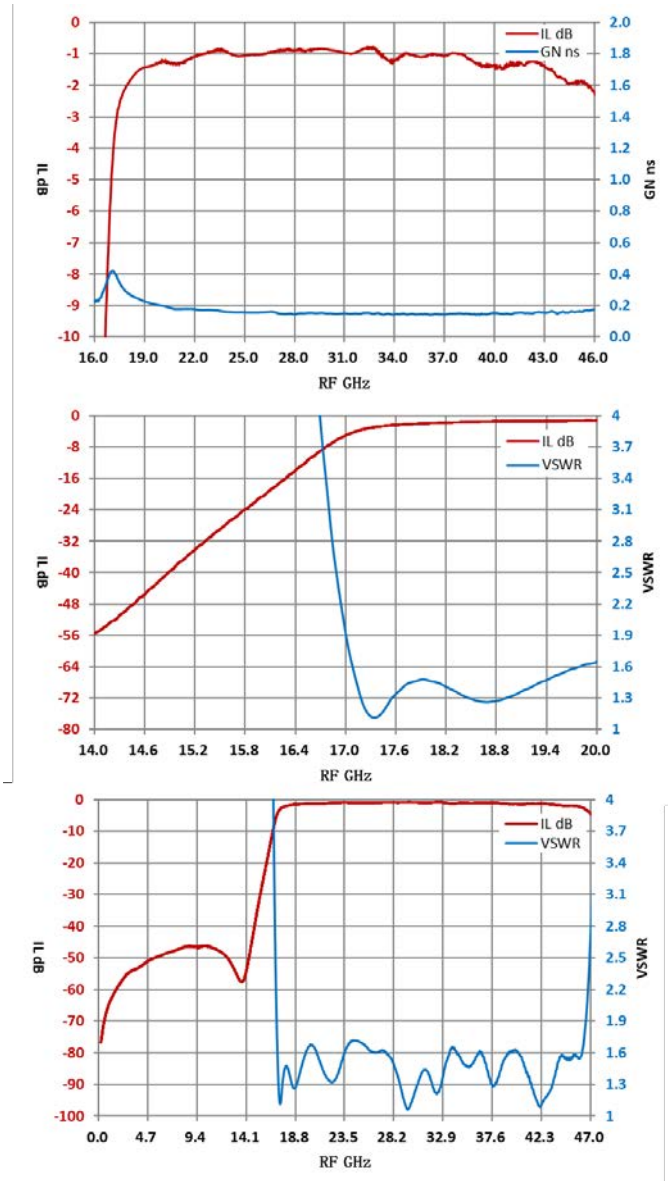
参考图



原理图



典型曲线



产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

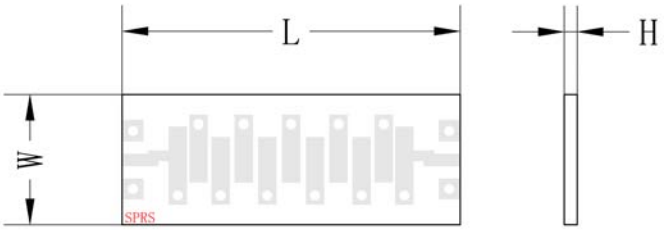
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	32.5	GHz
工作带宽	19.0-46.0	GHz
通带损耗	1.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	20@13.0-15.0GHz	dBc
带外抑制	35@DC-13.0GHz	dBc

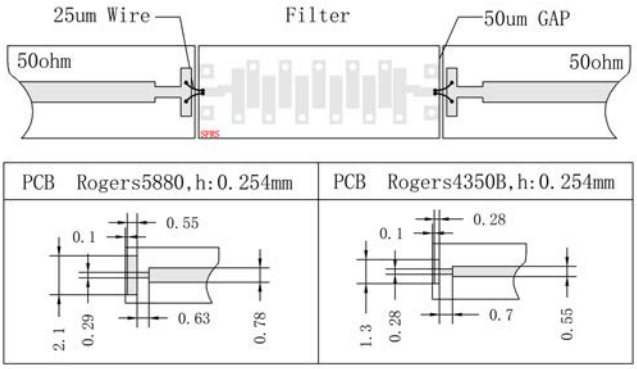
其它要求：设计保证

承受功率	0.5W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：3.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

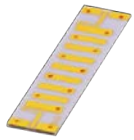
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

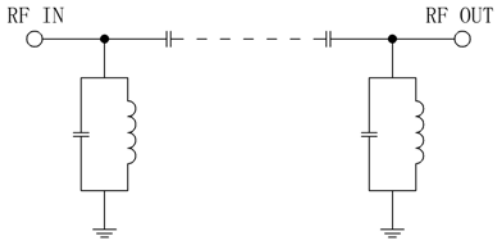
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

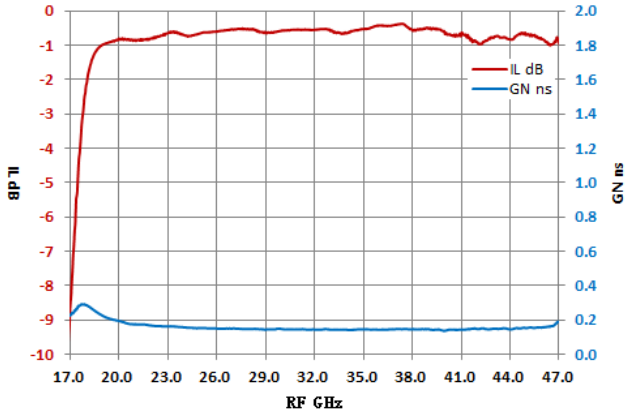
参考图

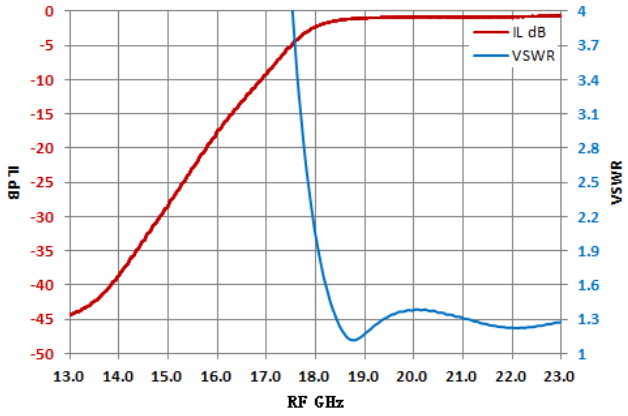


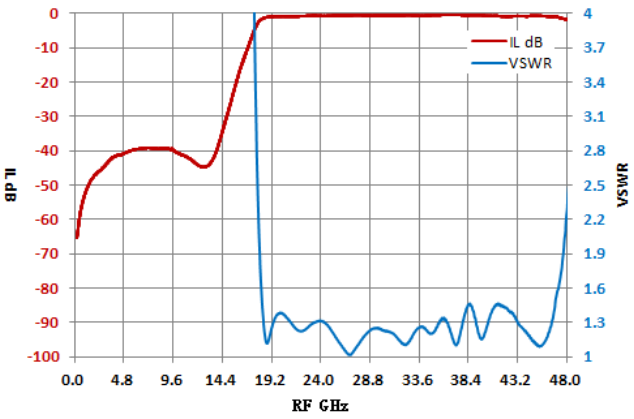
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

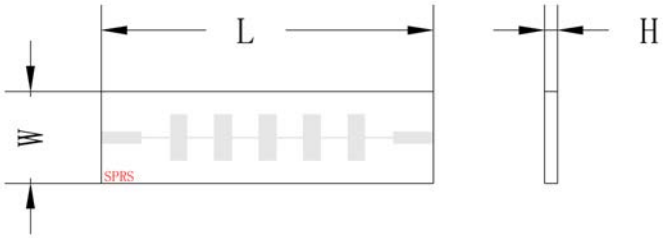
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.1	GHz
工作带宽	8.6-9.6	GHz
通带损耗	2.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@4.2-8.1GHz	dBc

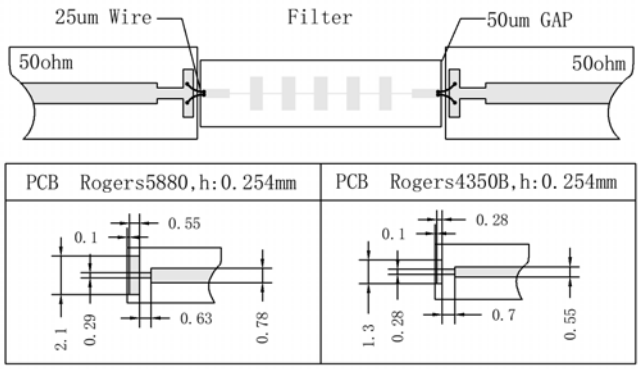
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：4.5，W：4.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

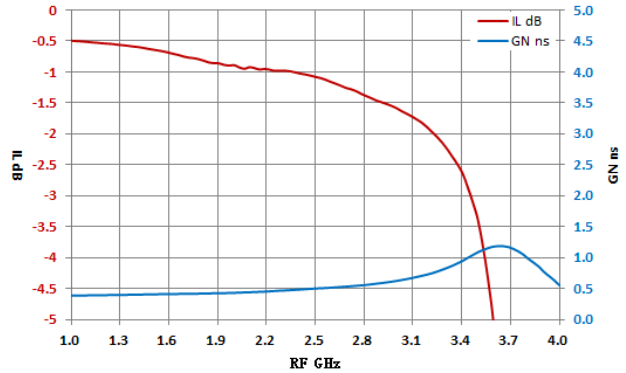
参考实物图

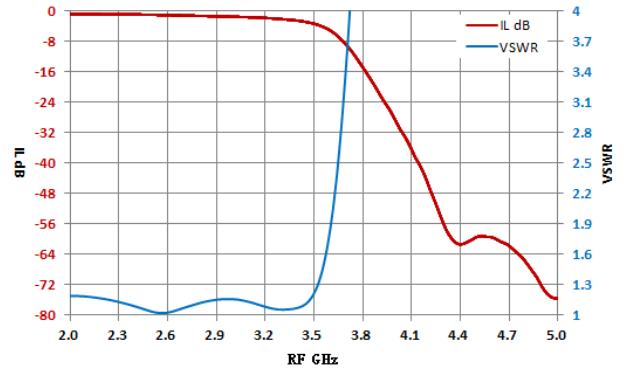


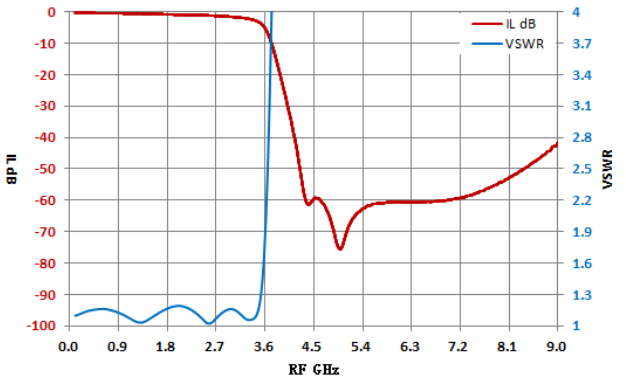
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

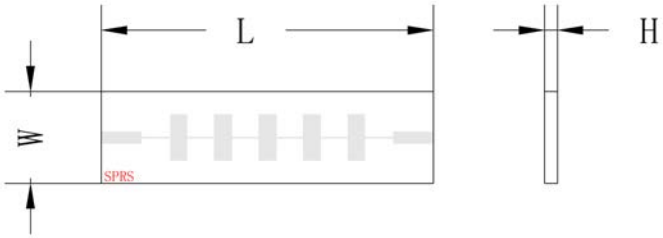
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	1.65	GHz
工作带宽	DC-3.3	GHz
通带损耗	2.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@4.7-9.0GHz	dBc

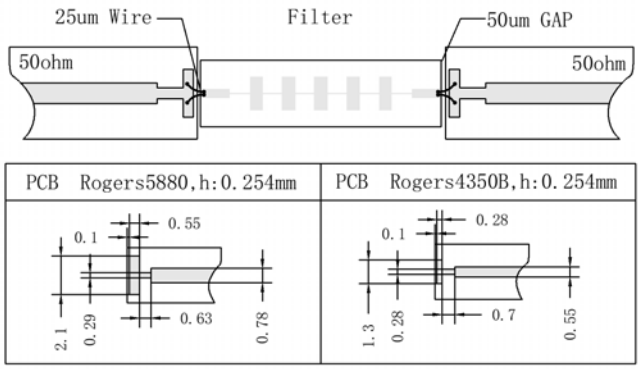
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：4.5，W：4.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

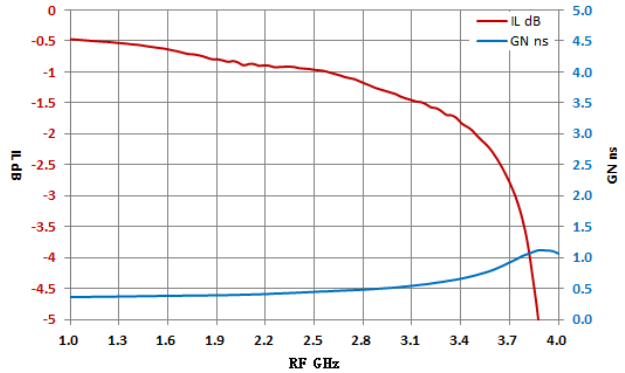
参考实物图

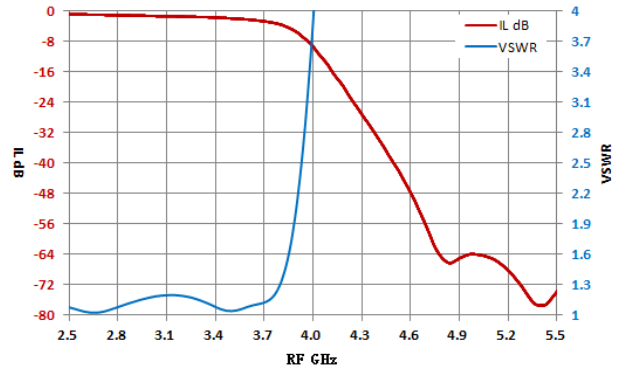


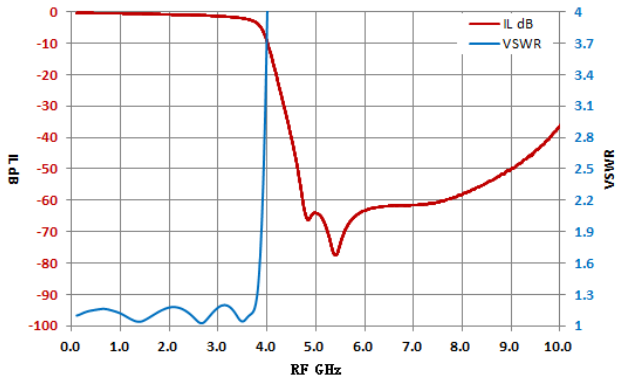
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



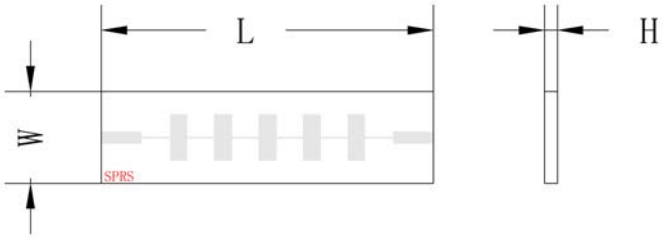
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	1.85	GHz
工作带宽	DC-3.7	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.5	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	35@5.1-8.0GHz	dBc

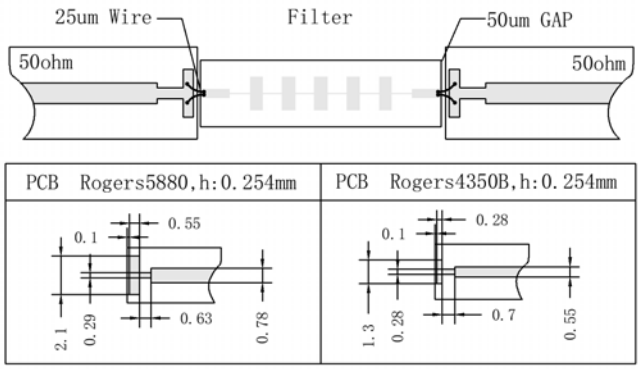
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：5.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



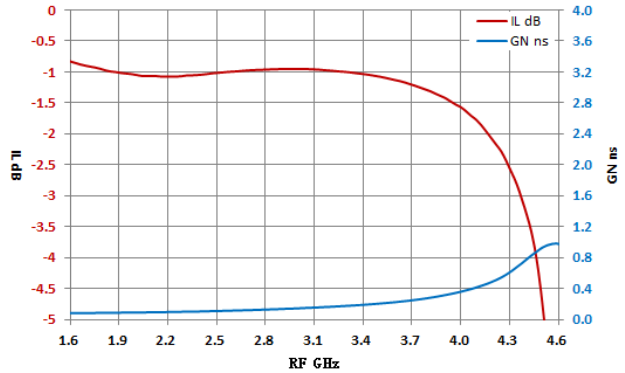
注意事项

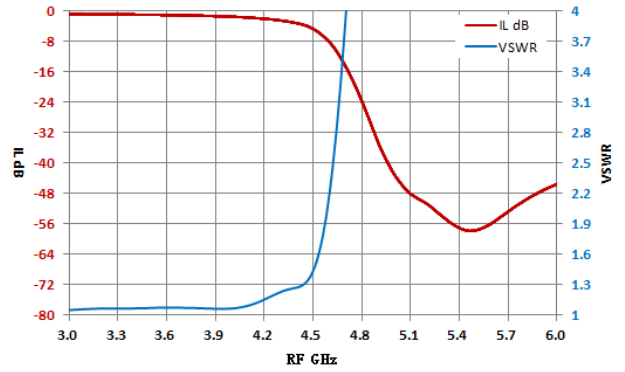
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

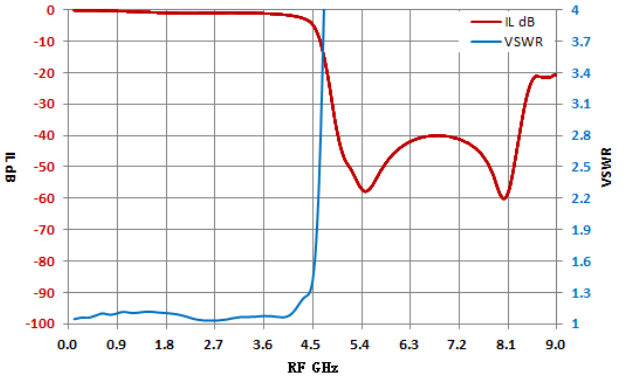
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

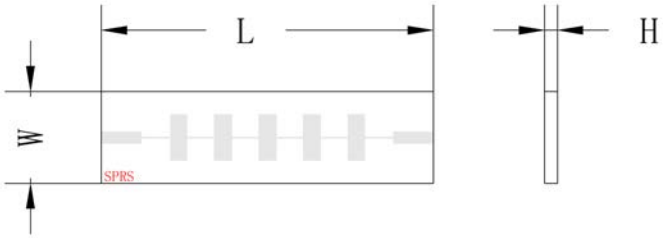
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.1	GHz
工作带宽	8.6-9.6	GHz
通带损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@5.2-10.8GHz	dBc

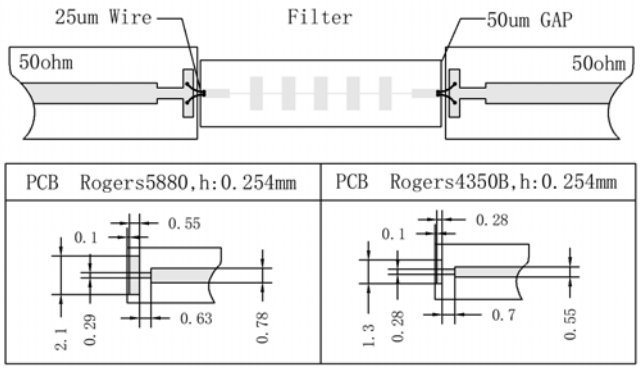
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：4.5，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

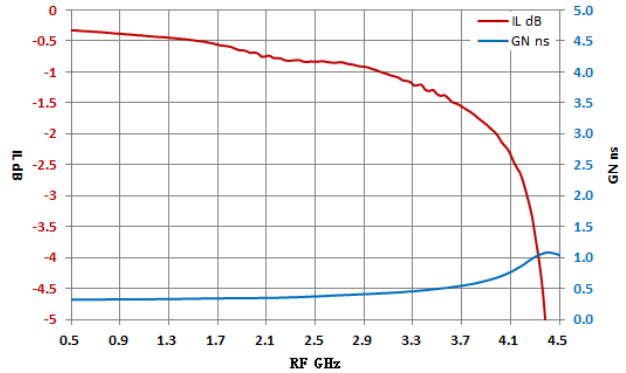
参考实物图

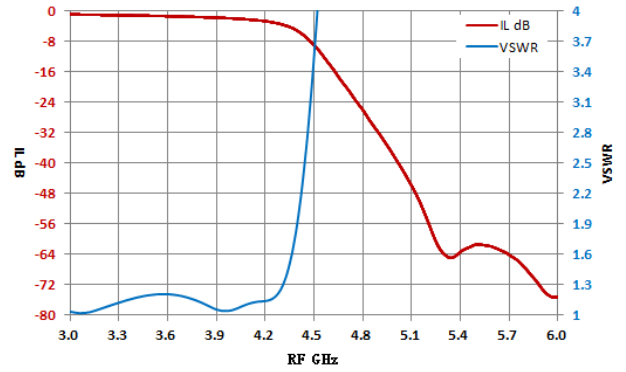


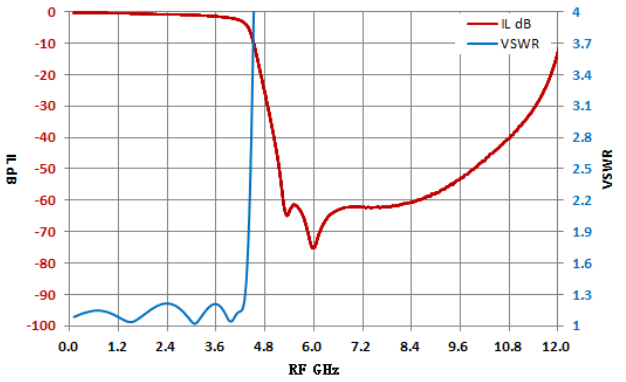
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



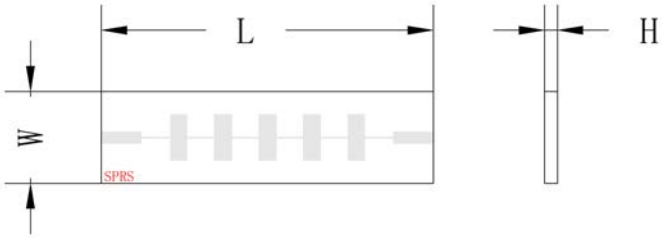
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	1.9	GHz
工作带宽	DC-3.8	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.5	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@4.9-8.0GHz	dBc

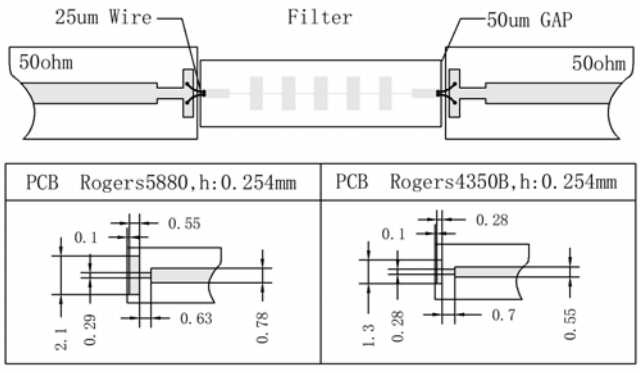
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：5.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



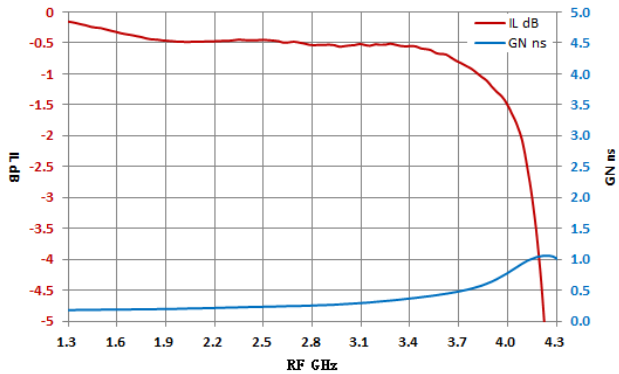
注意事项

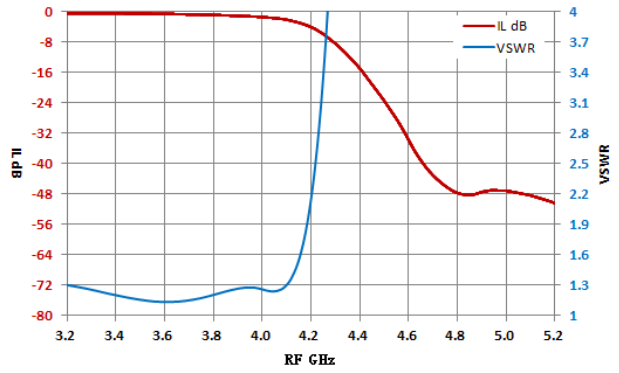
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

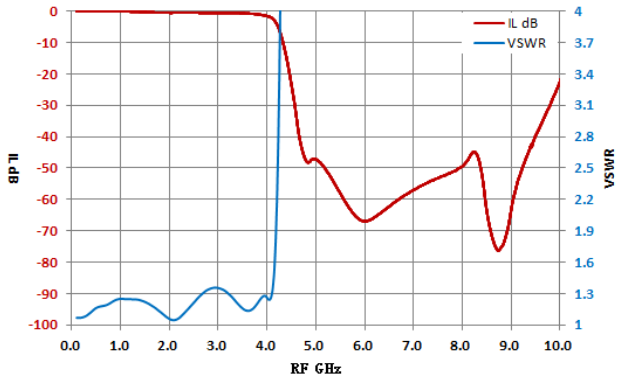
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

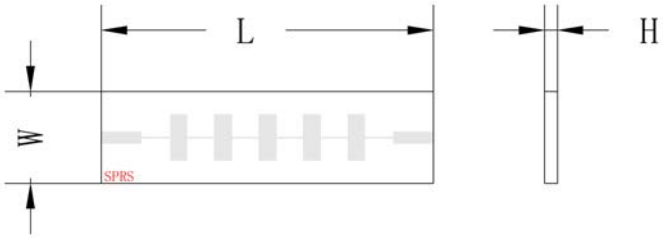
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	1.9	GHz
工作带宽	DC-3.8	GHz
通带损耗	2.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@5.2-10.0GHz	dBc

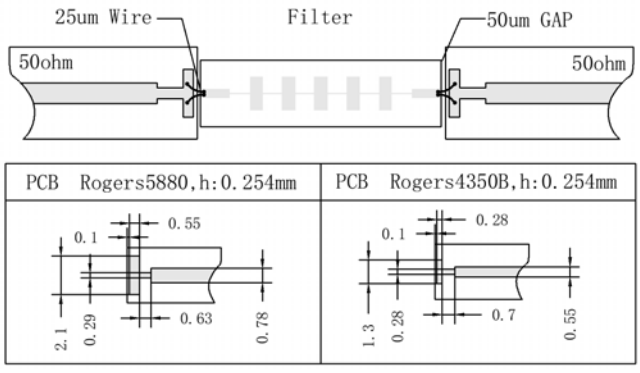
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：4.5，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

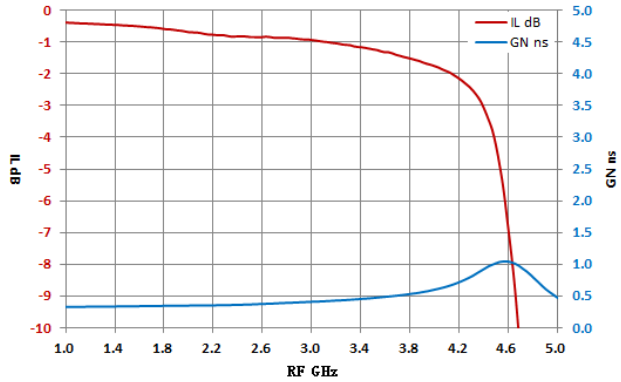
参考实物图

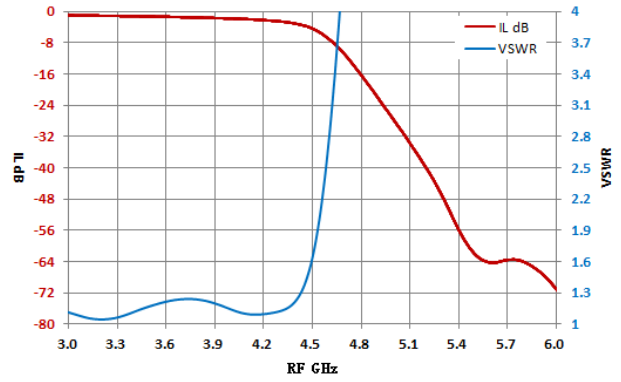


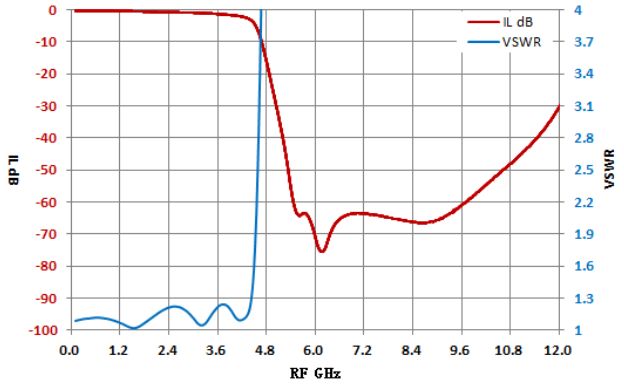
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



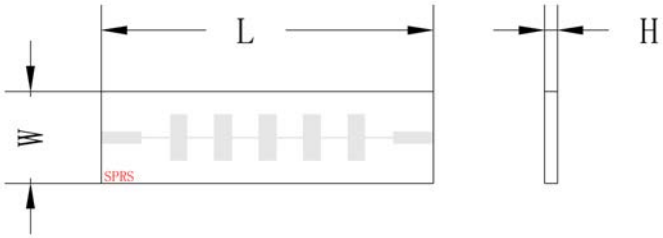
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	2.1	GHz
工作带宽	DC-4.2	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.5	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@5.9-10.0GHz	dBc

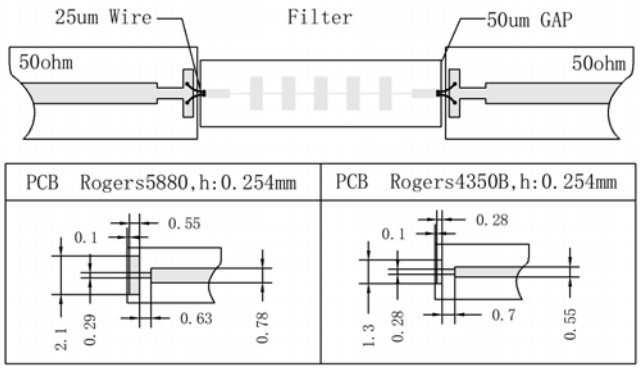
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：5.0，h：0.26

外形图：端口居中



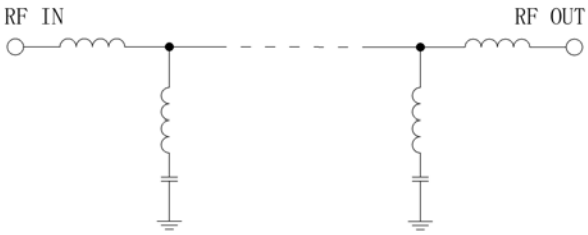
推荐装配图



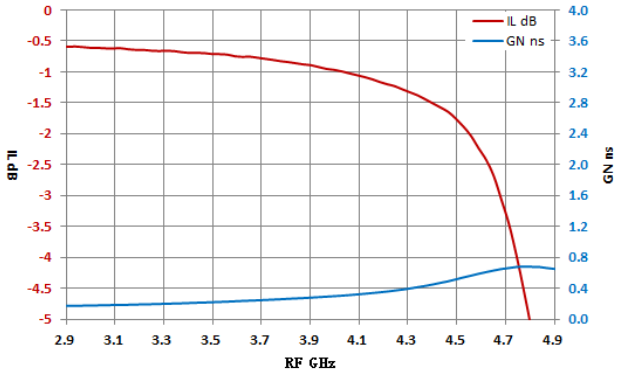
注意事项

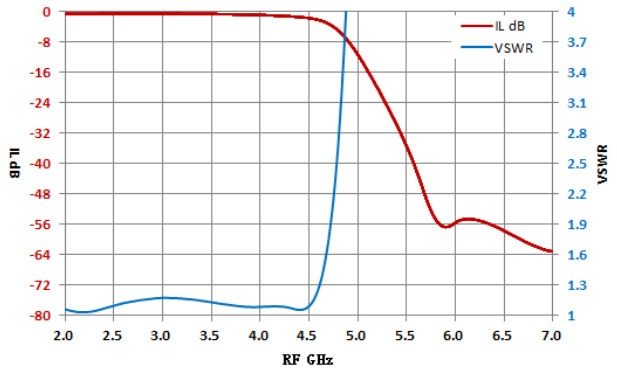
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

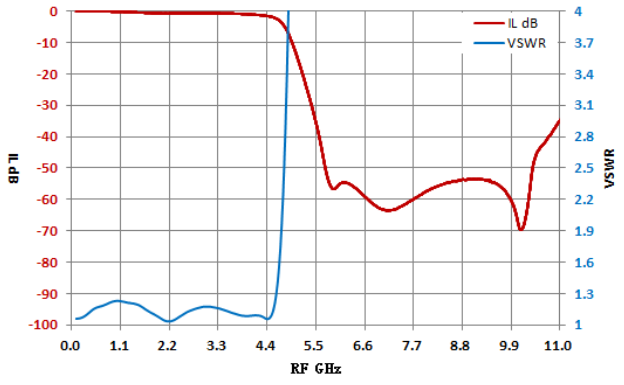
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

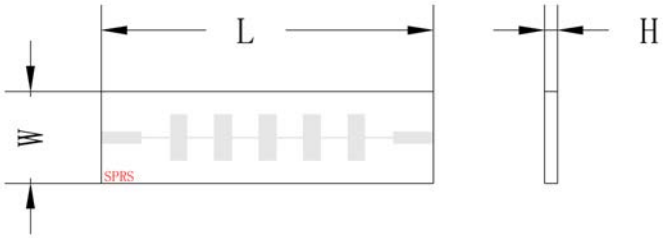
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	2.15	GHz
工作带宽	DC-4.3	GHz
通带损耗	1.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@6.0-11.7GHz	dBc

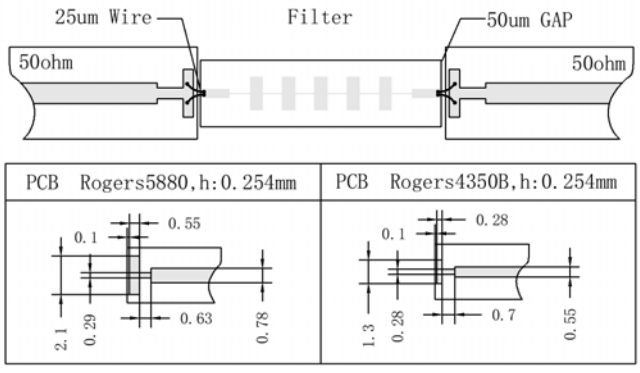
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：4.5，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

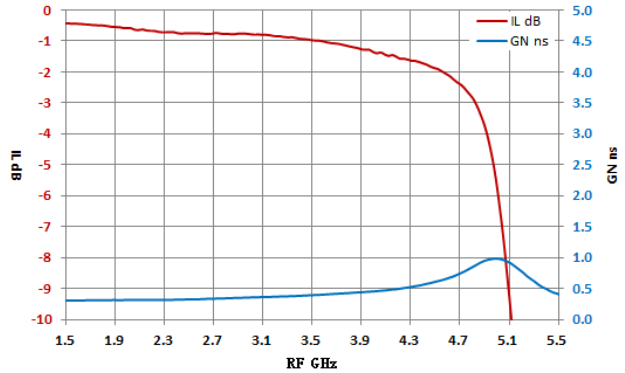
参考实物图

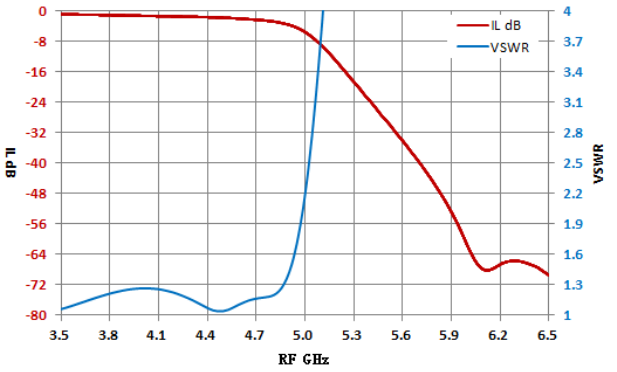


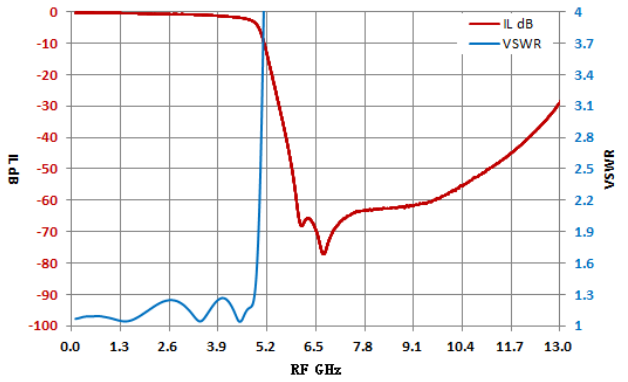
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



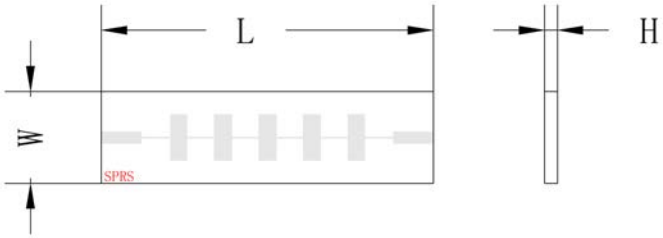
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	2.4	GHz
工作带宽	DC-4.8	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.5	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	35@6.5-11.0GHz	dBc

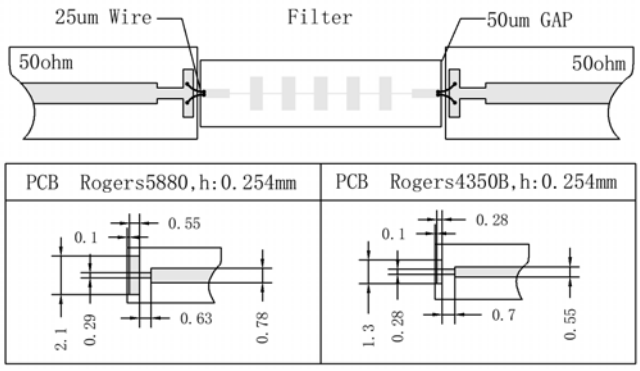
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



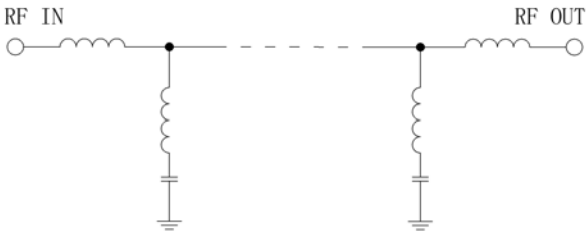
推荐装配图



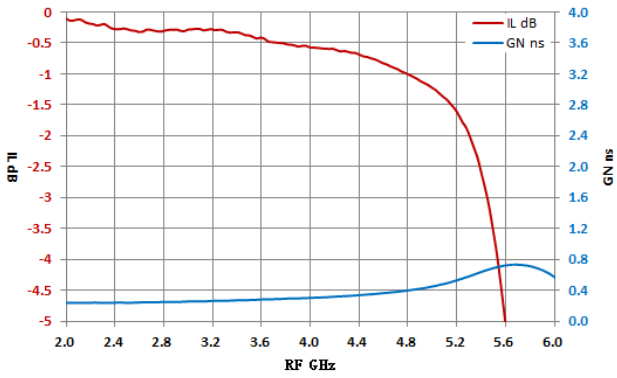
注意事项

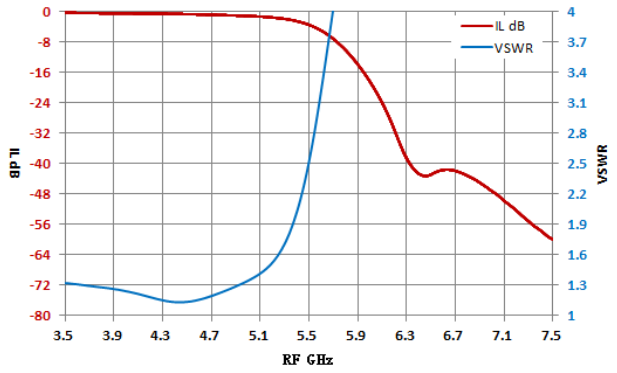
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

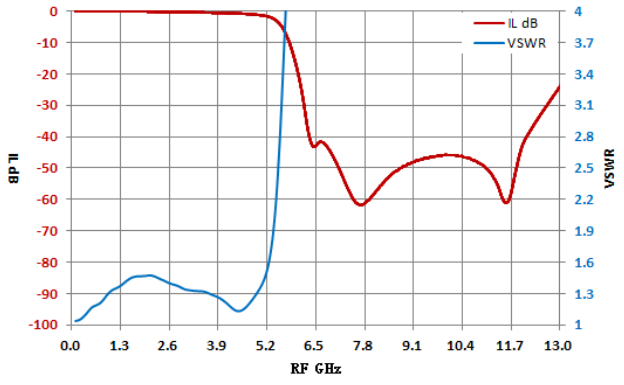
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

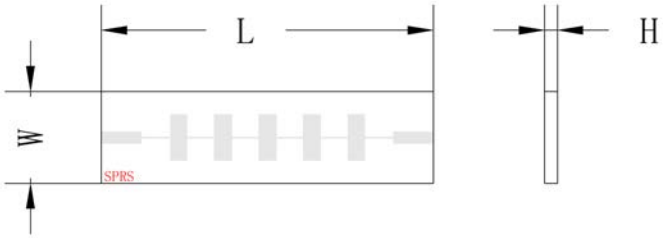
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	2.4	GHz
工作带宽	DC-4.8	GHz
通带损耗	1.8	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@6.5-13.5GHz	dBc

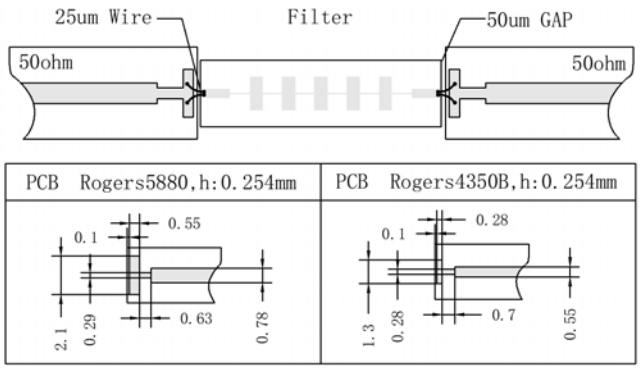
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：4.5，W：3.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

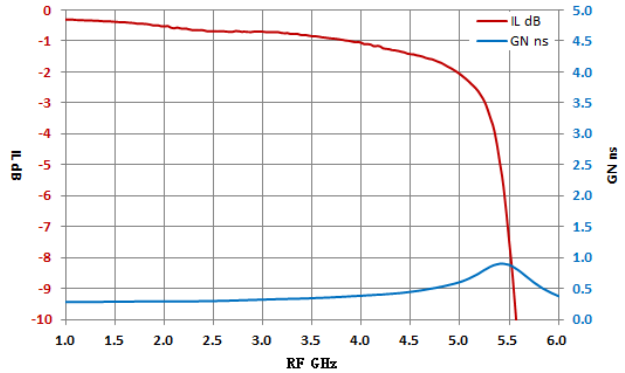
参考实物图

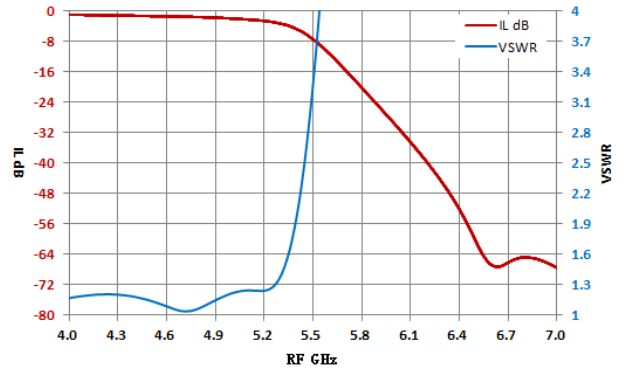


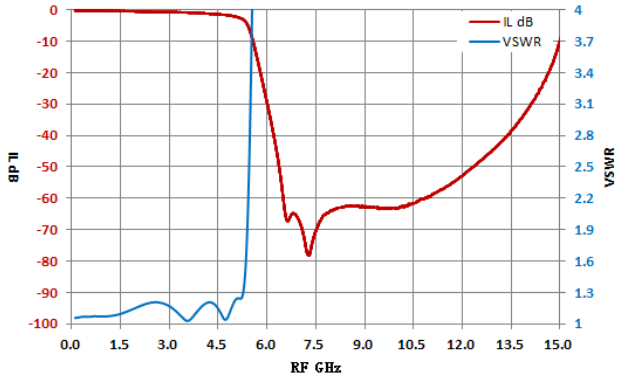
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



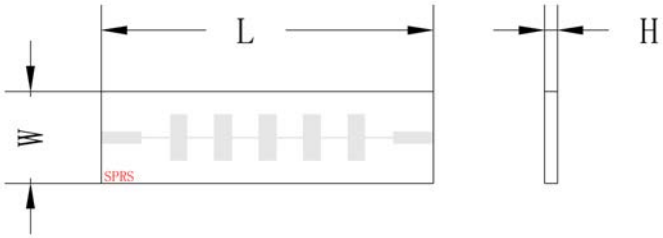
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	2.75	GHz
工作带宽	DC-5.5	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.01.5	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	35@7.2-13.0GHz	dBc

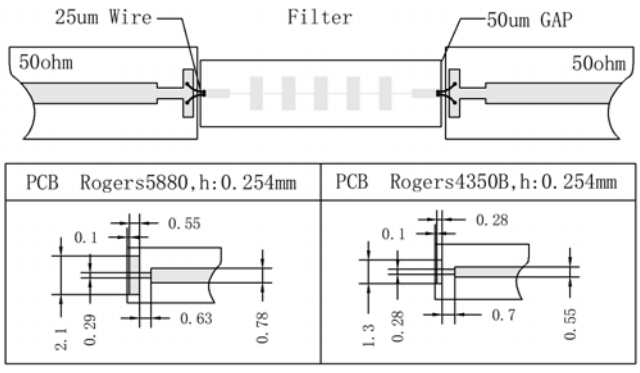
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



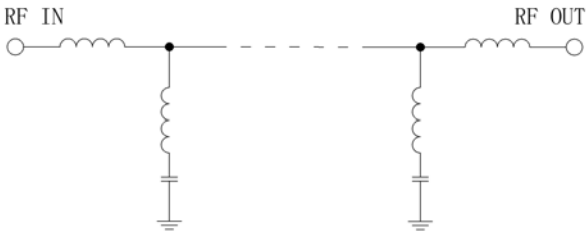
推荐装配图



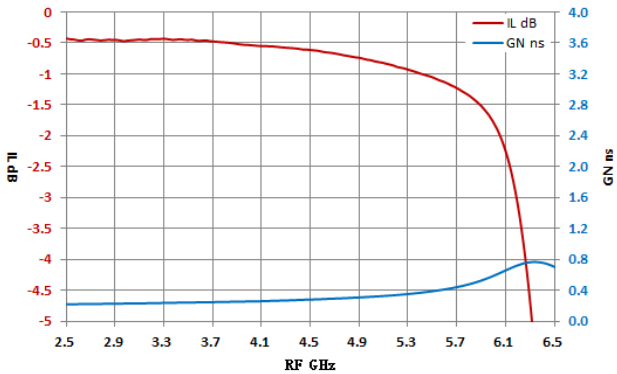
注意事项

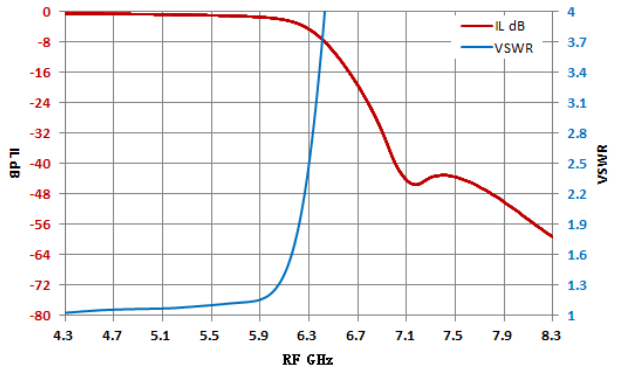
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

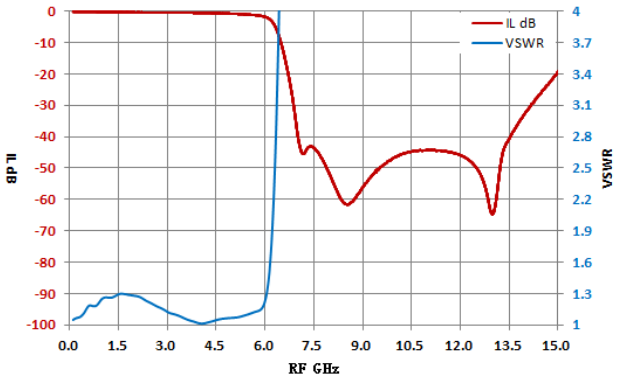
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

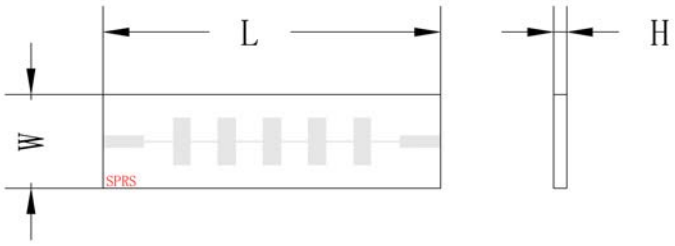
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	2.9	GHz
工作带宽	DC-5.8	GHz
通带损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@8.0-13.5GHz	dBc

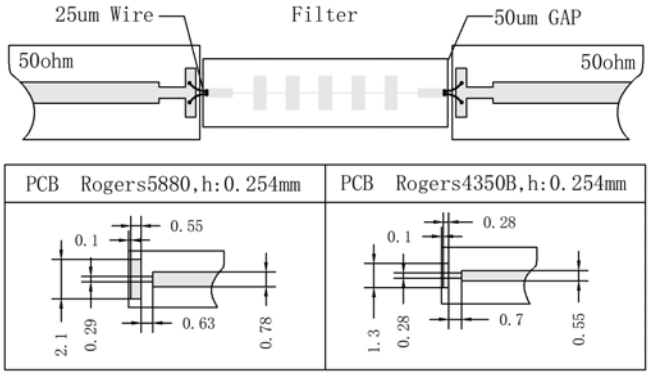
其它要求：设计保证

承受功率	0.5W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：6.5，W：5.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

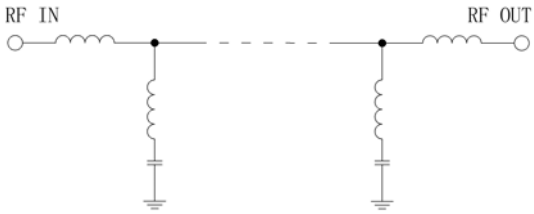
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

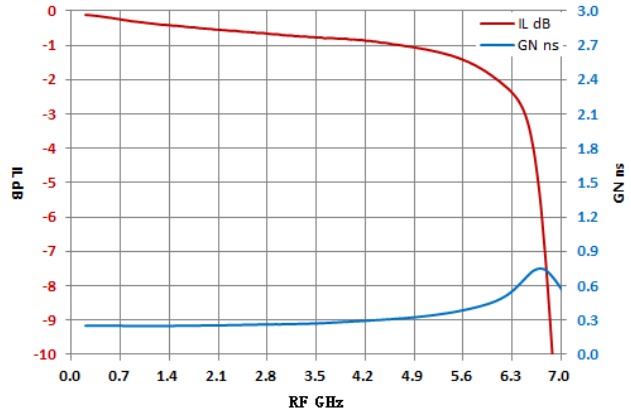
参考图

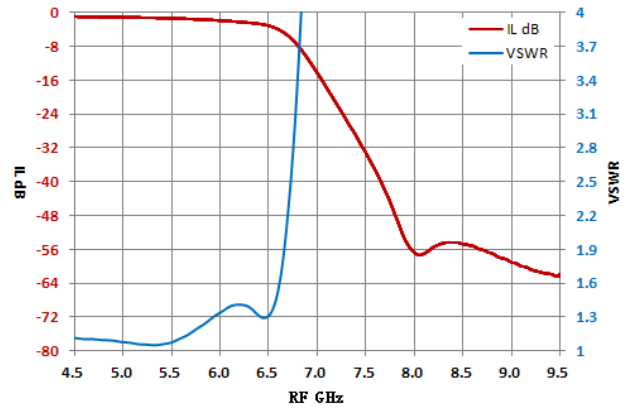


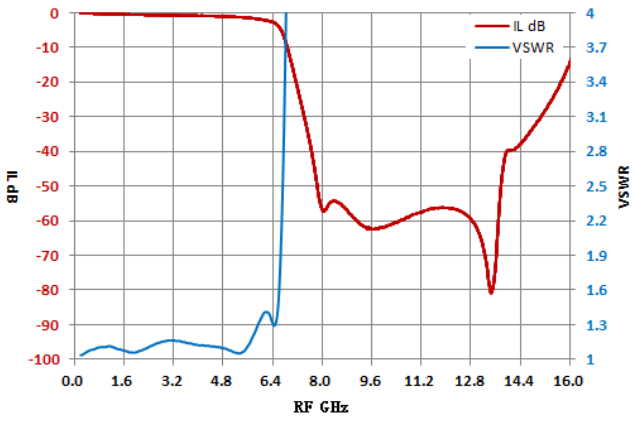
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

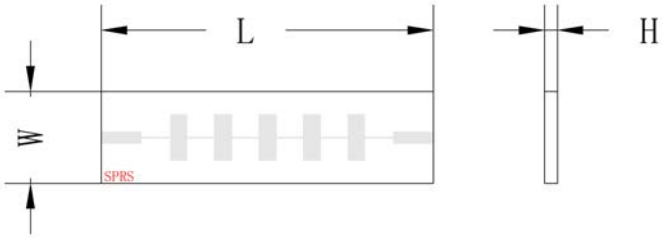
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	3.0	GHz
工作带宽	DC-6.0	GHz
通带损耗	2.1	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@8.3-15.0GHz	dBc

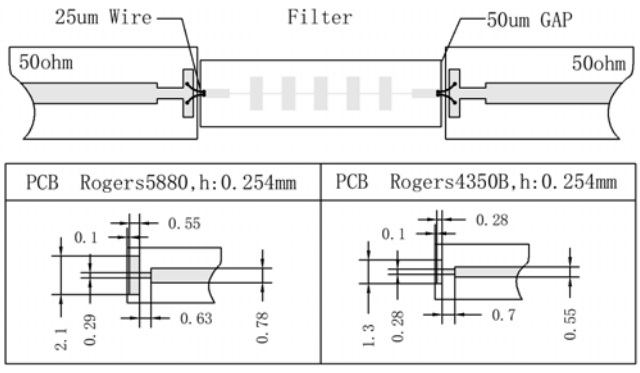
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：5.0，W：3.9，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

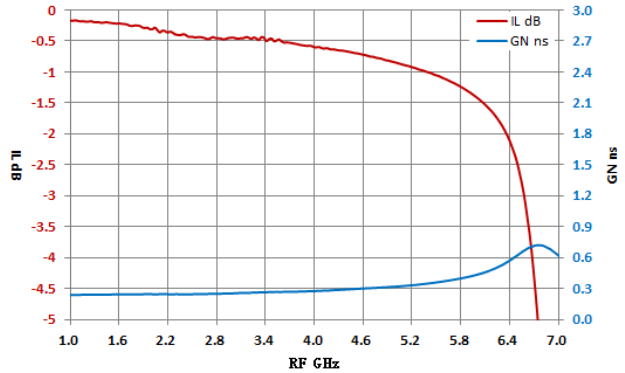
参考实物图

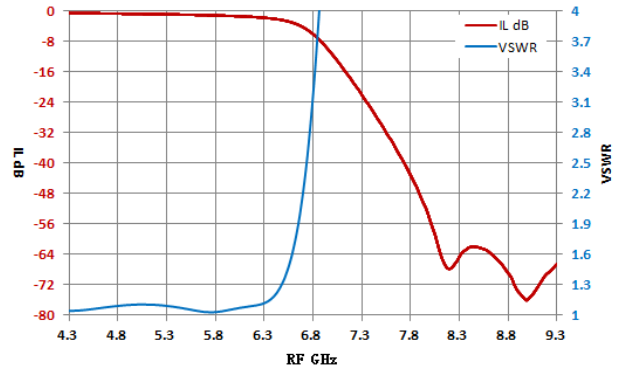


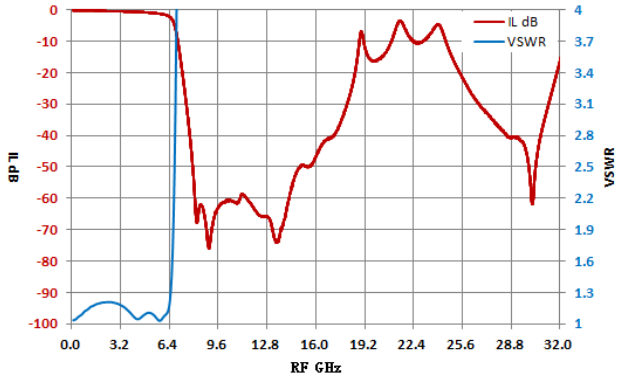
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

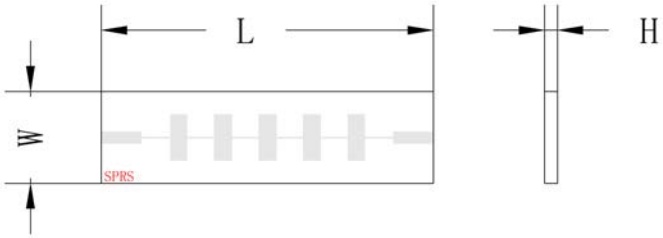
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	3.05	GHz
工作带宽	DC-6.1	GHz
通带损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@8.0-15.0GHz	dBc

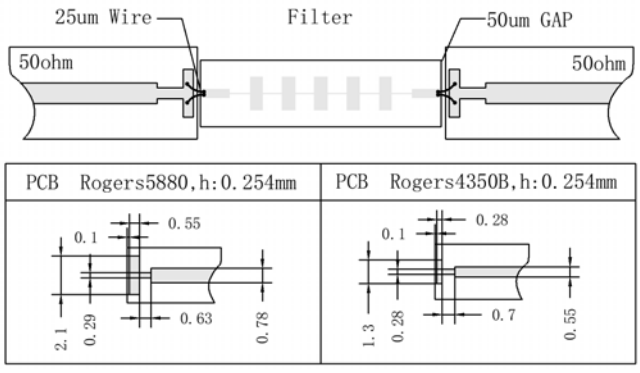
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：4.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

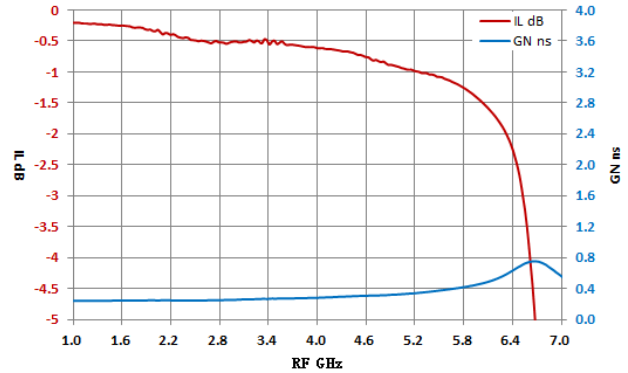
参考实物图

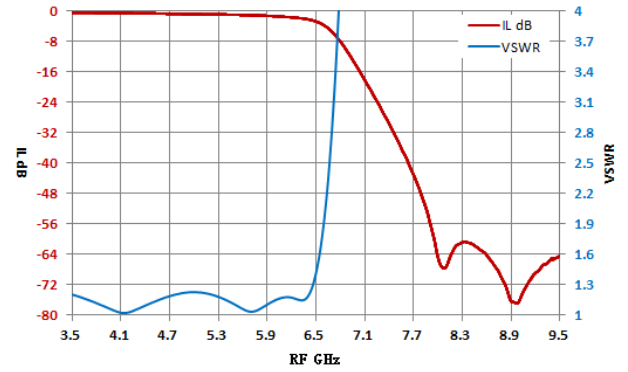


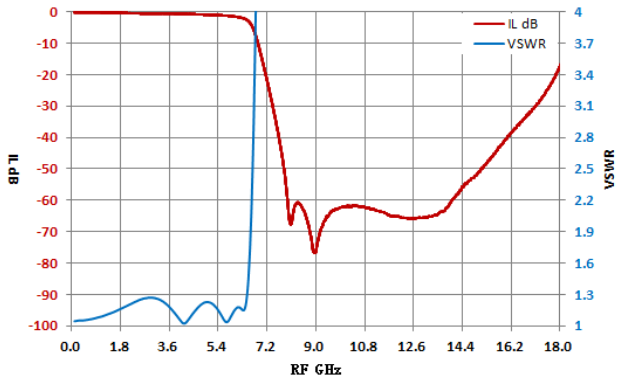
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

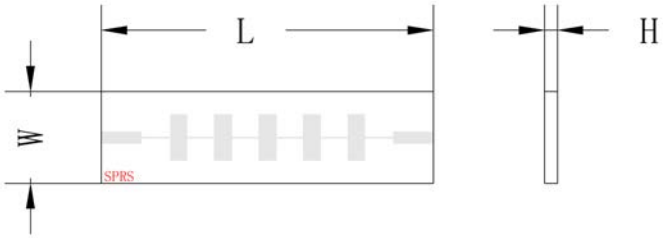
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	3.35	GHz
工作带宽	DC-6.7	GHz
通带损耗	1.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@8.8-16.0GHz	dBc

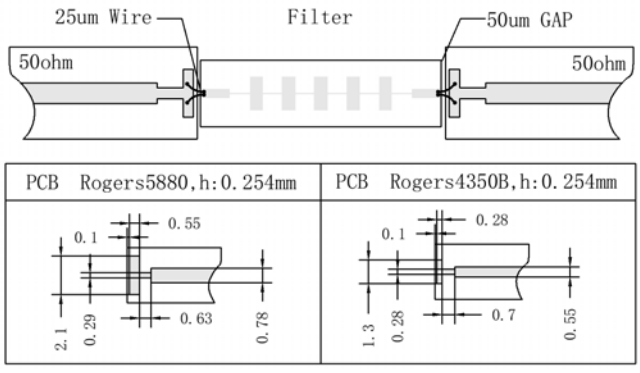
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：4.5，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

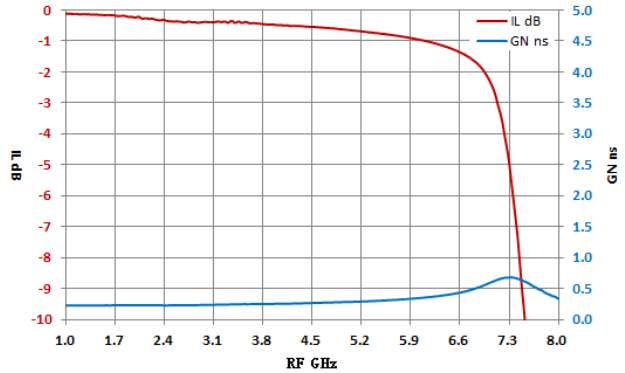
参考实物图

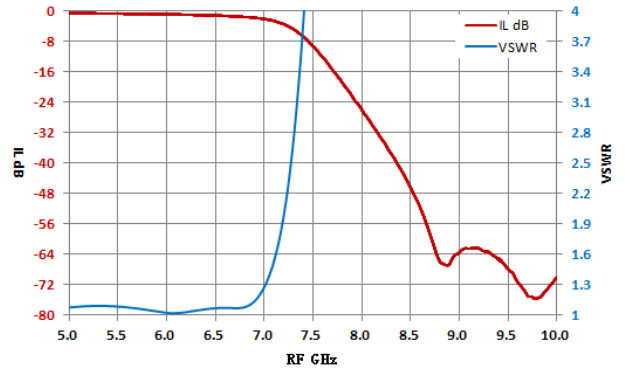


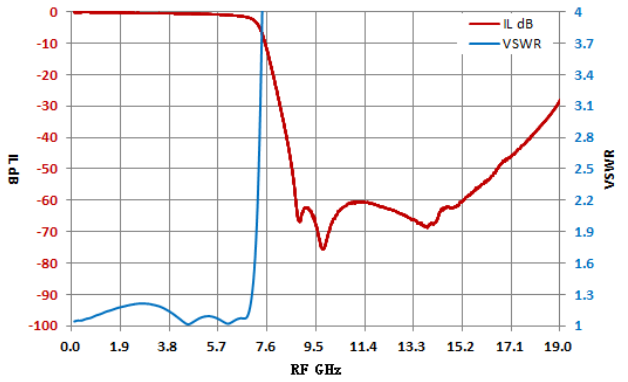
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



技术要求

项目	参数	单位
中心频率	3.4	GHz
工作带宽	DC-6.8	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.5	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	30@8.3-14.0GHz	dBc

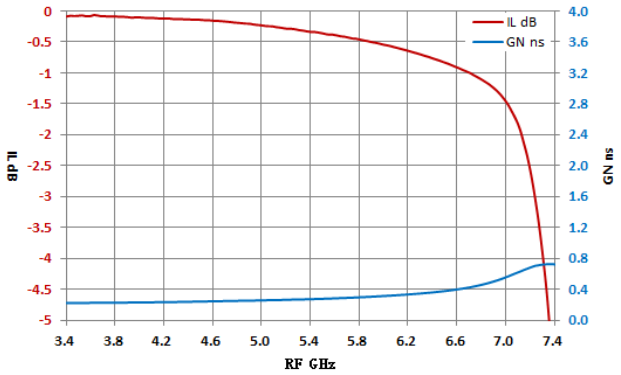
原理图

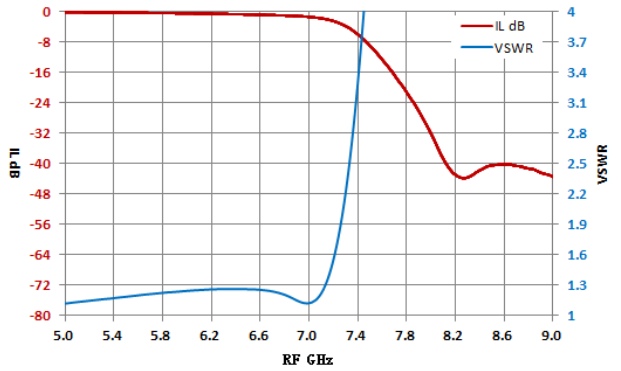


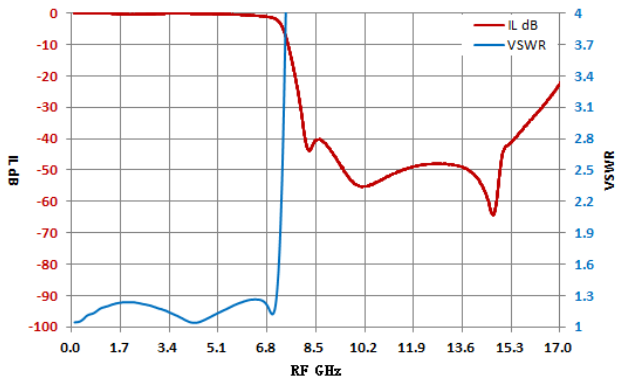
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：3.0，h：0.26

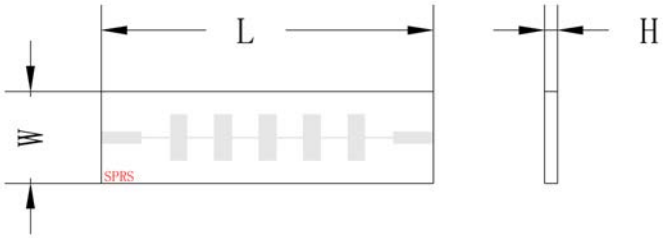
典型曲线



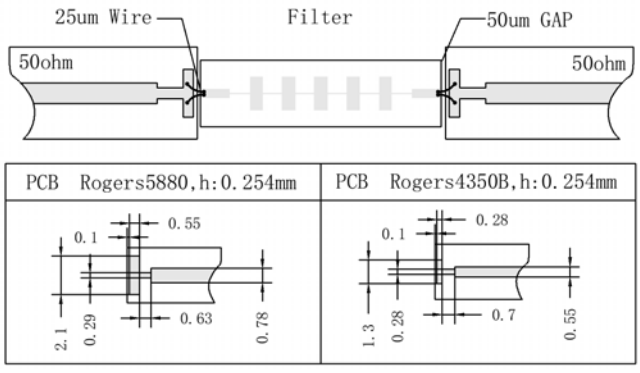




外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



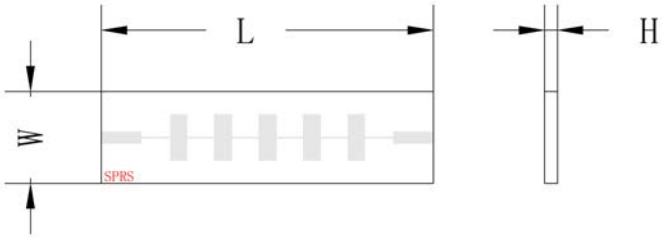
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	3.75	GHz
工作带宽	DC-7.5	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.5	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	30@9.6-17.0GHz	dBc

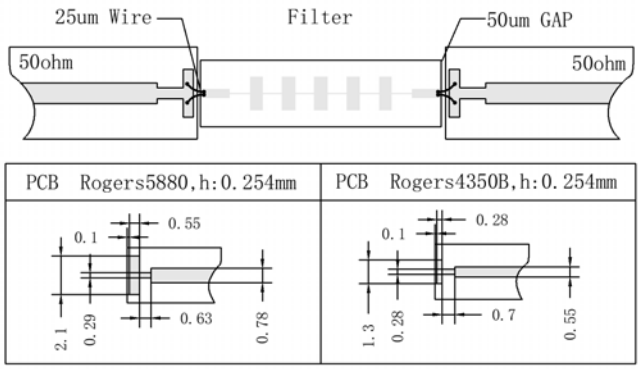
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：5.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



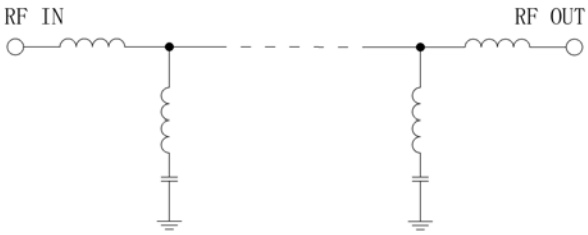
推荐装配图



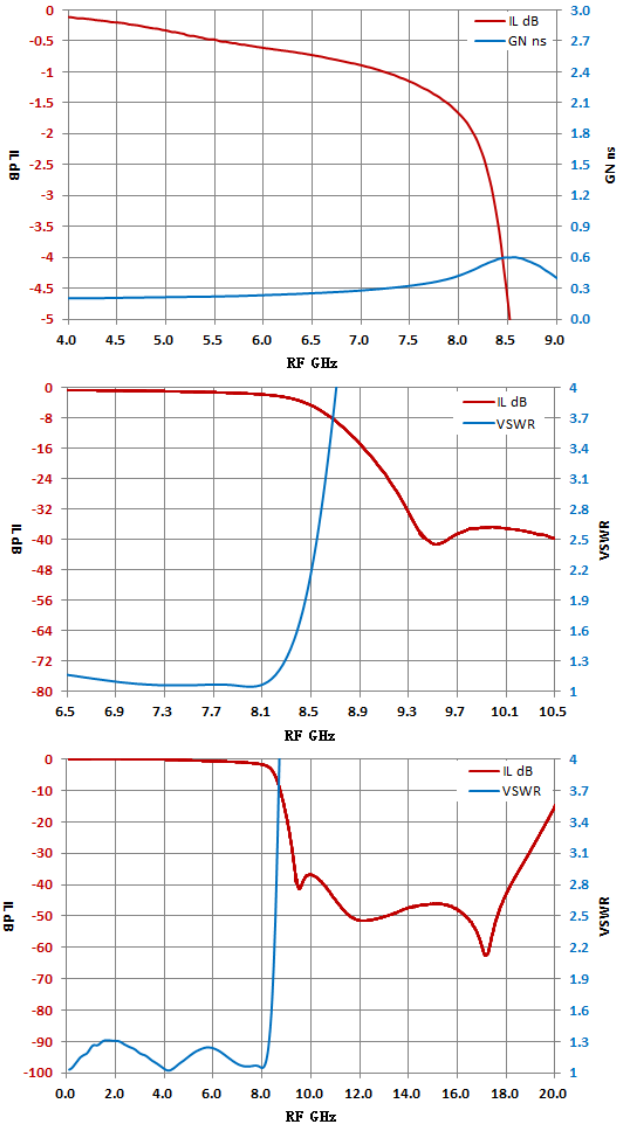
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线



产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



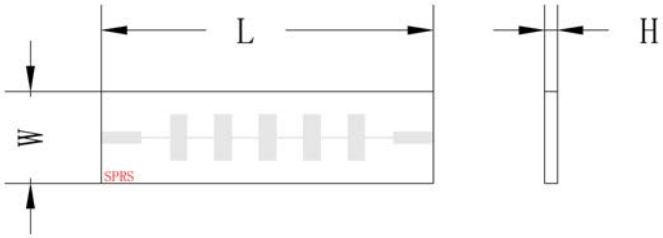
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	3.75	GHz
工作带宽	DC-7.5	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.5	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	35@11.4-39.0GHz	dBc

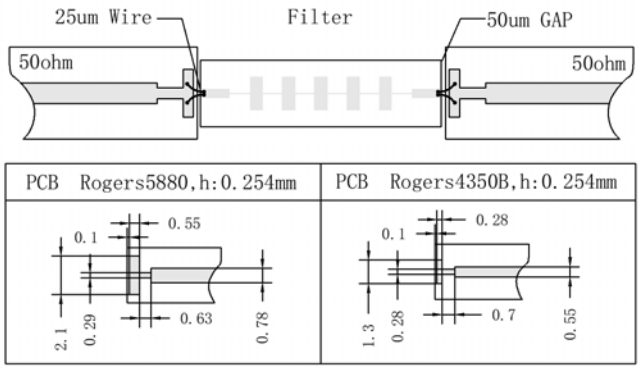
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：9.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



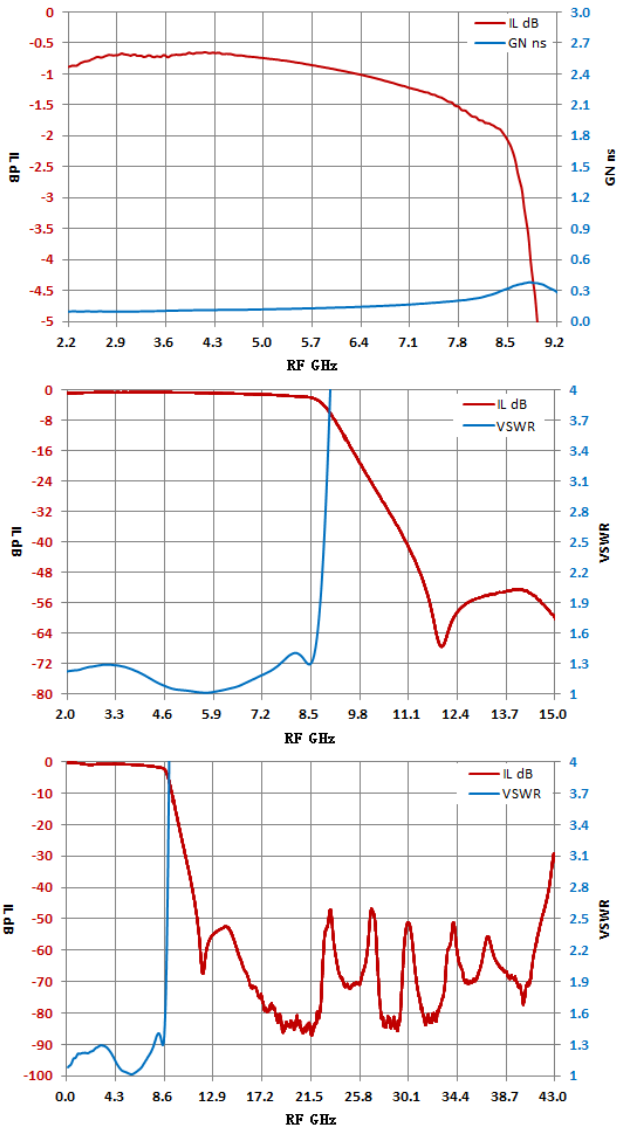
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线



产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

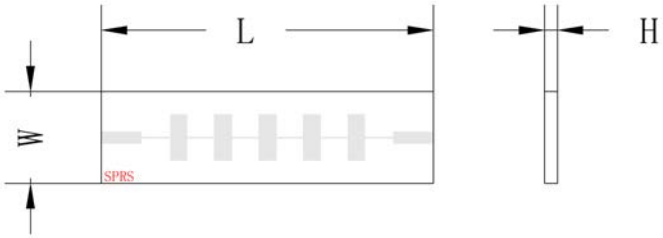
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	3.75	GHz
工作带宽	DC-7.5	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@9.8-19.0GHz	dBc

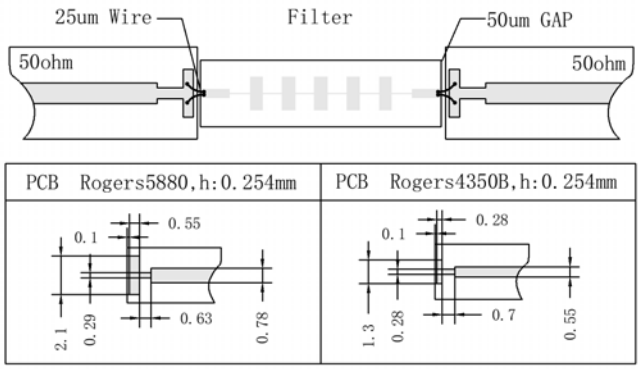
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：4.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

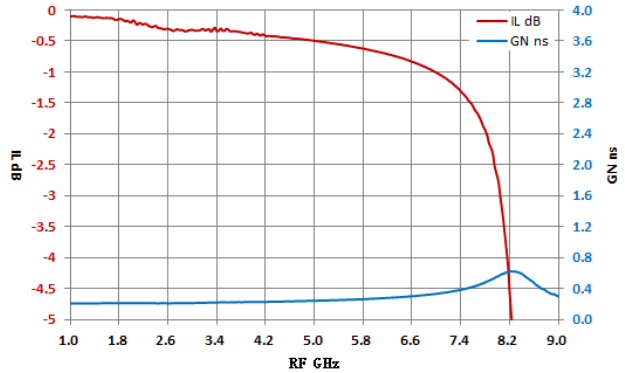
参考实物图

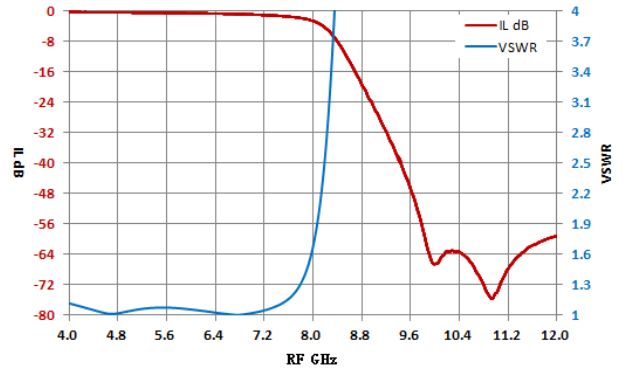


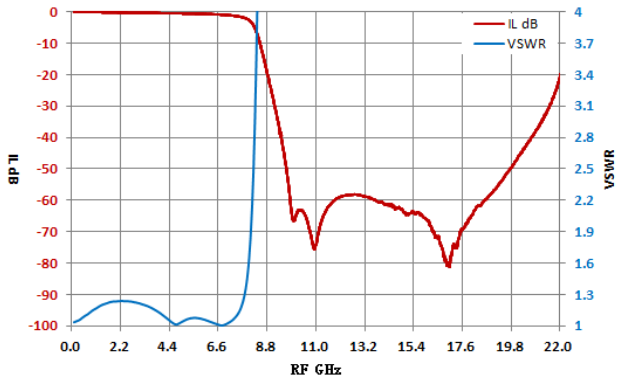
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

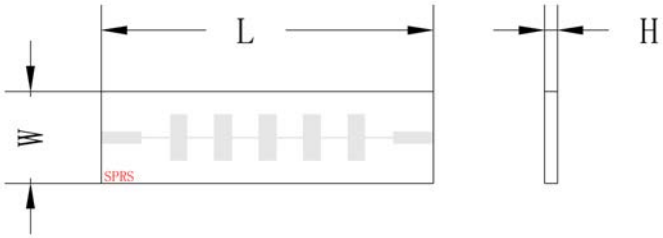
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	4.0	GHz
工作带宽	DC-8.0	GHz
通带损耗	1.7	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@10.9-22.0GHz	dBc

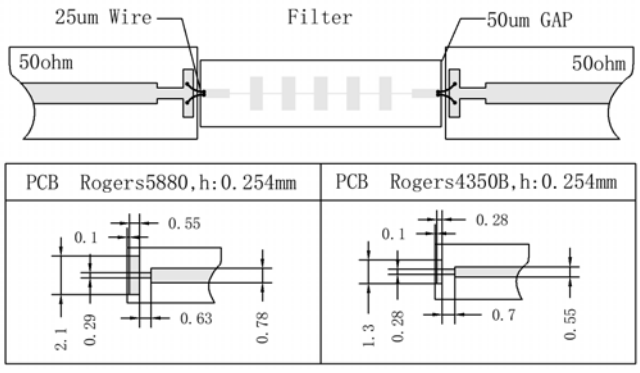
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：4.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

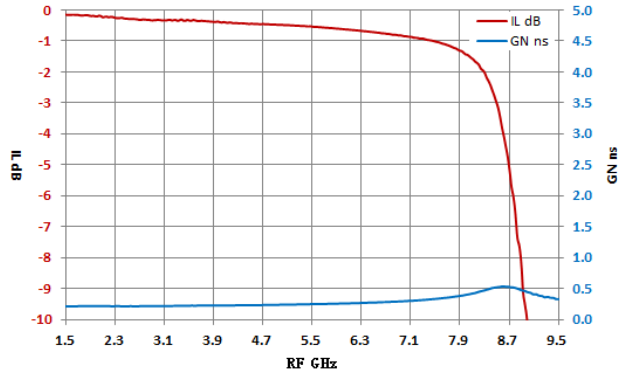
参考实物图

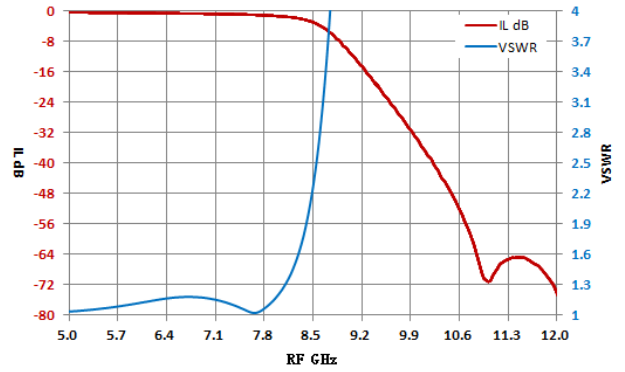


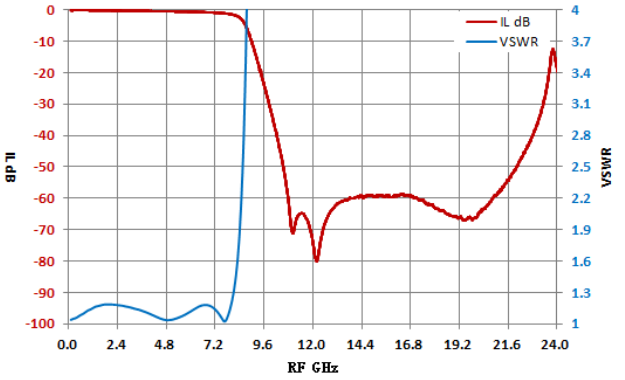
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



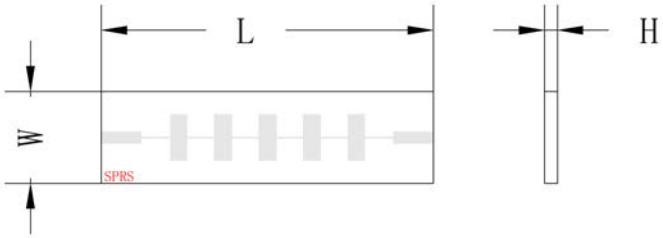
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	4.1	GHz
工作带宽	DC-8.2	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.5	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	30@10.3-18.0GHz	dBc

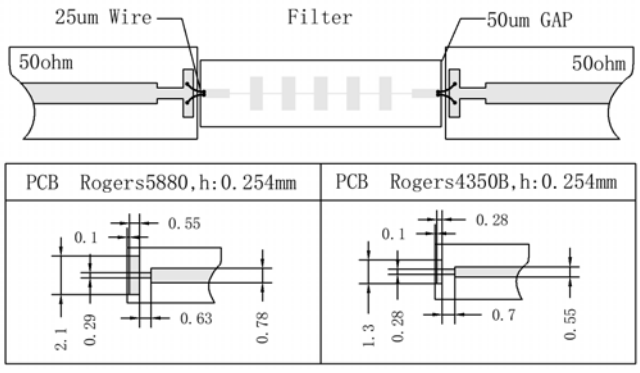
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：5.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



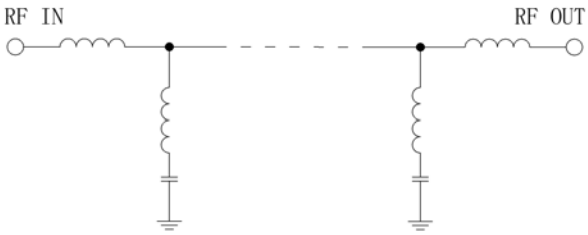
推荐装配图



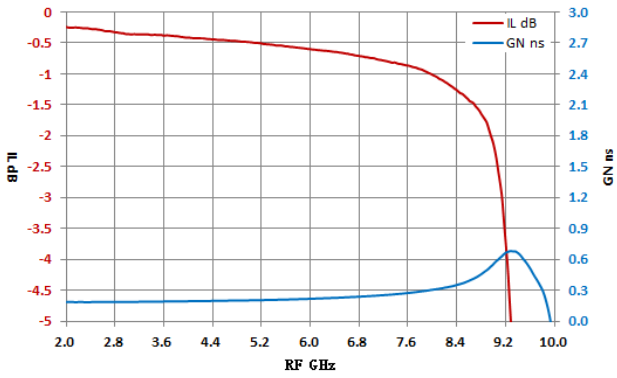
注意事项

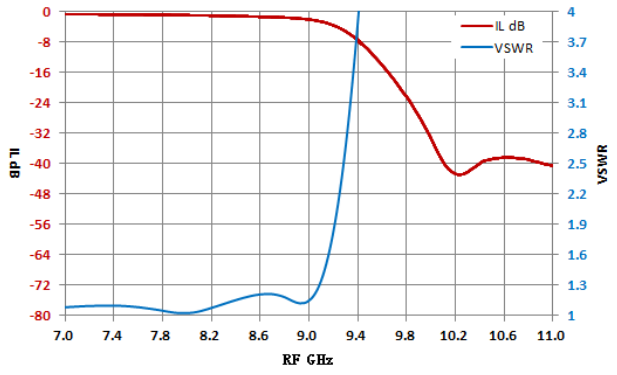
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

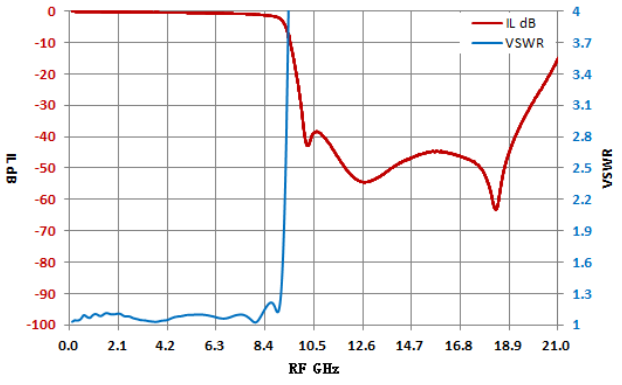
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

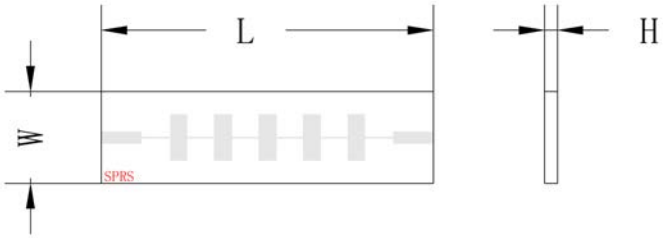
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	4.35	GHz
工作带宽	DC-8.7	GHz
通带损耗	1.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@11.3-24.6GHz	dBc

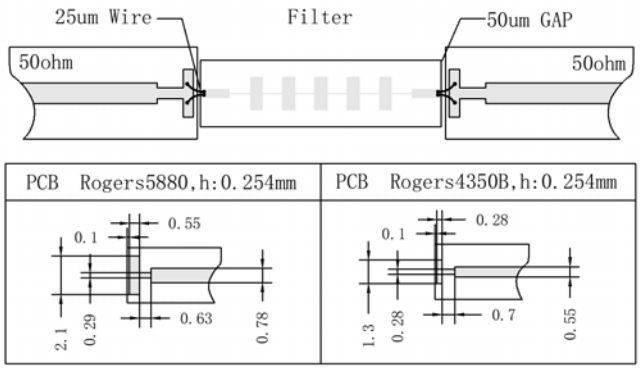
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：4.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

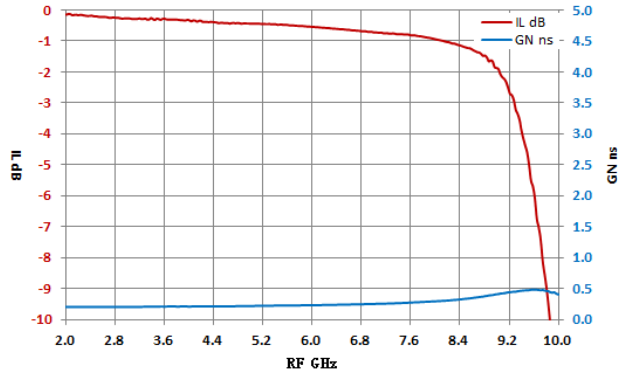
参考实物图

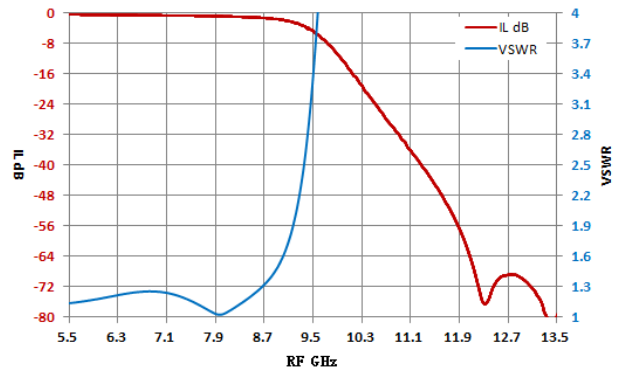


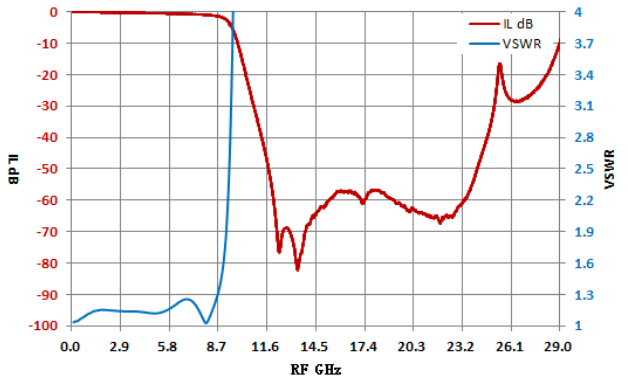
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



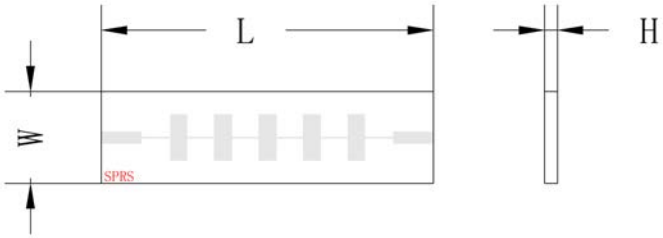
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	4.7	GHz
工作带宽	DC-9.4	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.5	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	30@11.3-20.0GHz	dBc

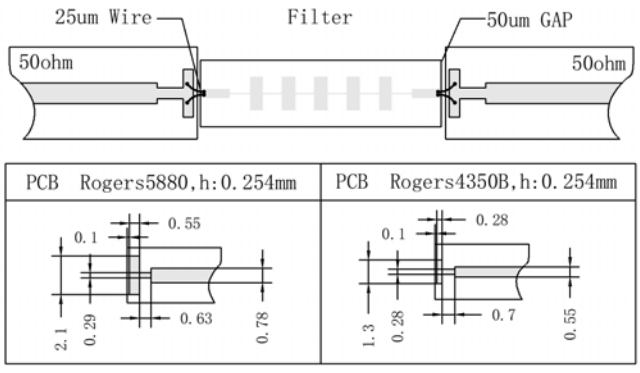
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：5.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



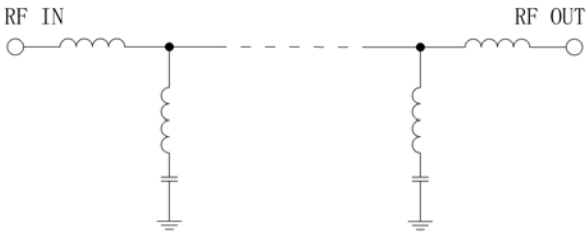
推荐装配图



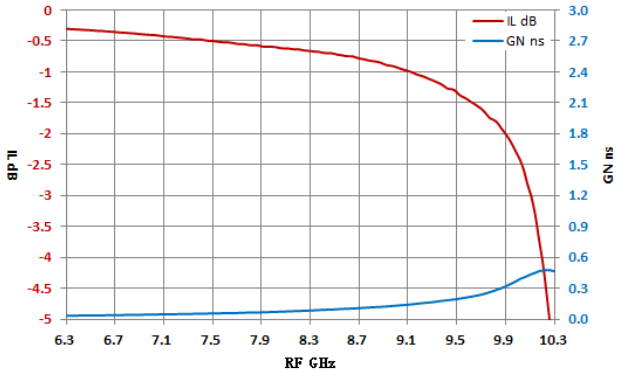
注意事项

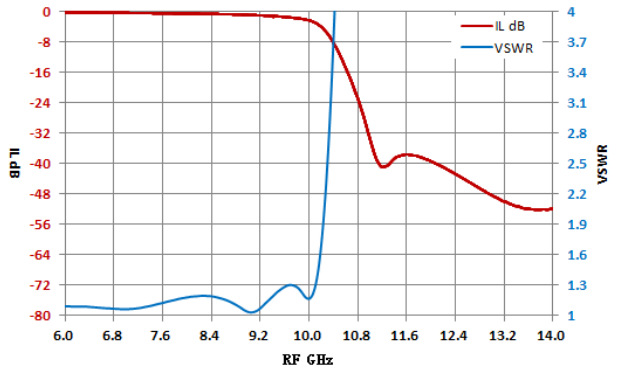
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

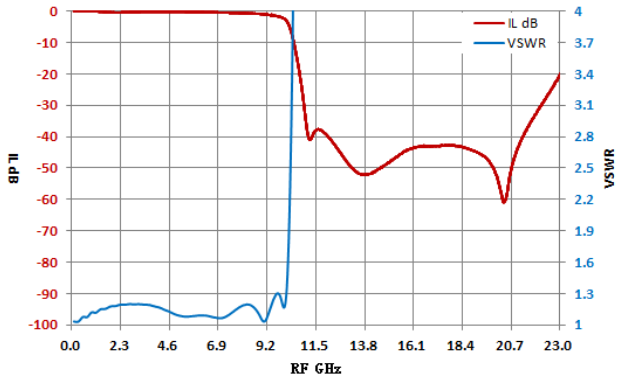
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

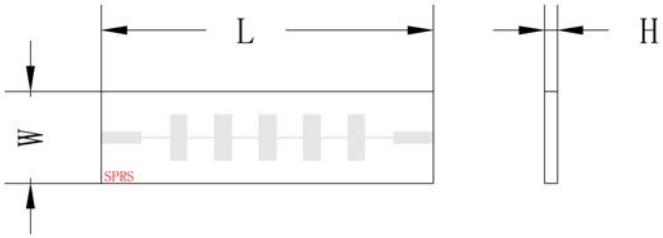
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	4.9	GHz
工作带宽	DC-9.8	GHz
通带损耗	1.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@13.2-25.2GHz	dBc

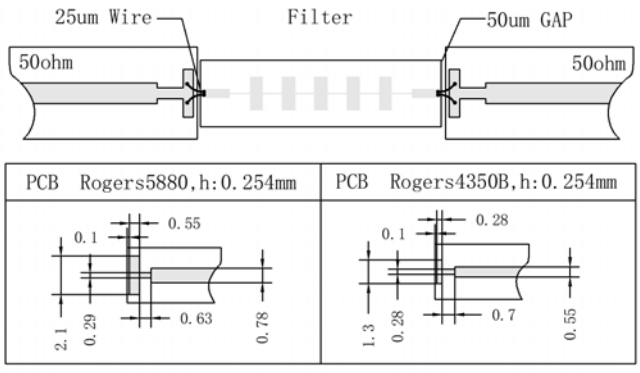
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：4.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

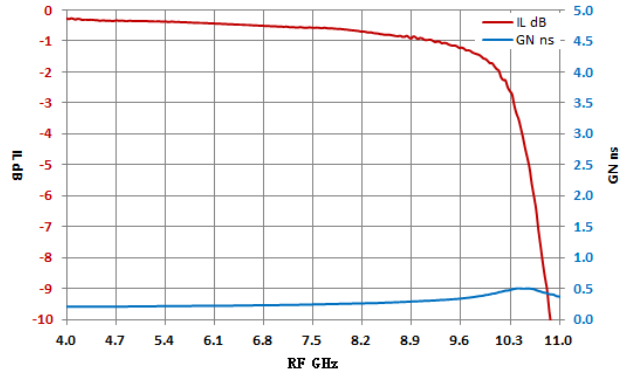
参考实物图

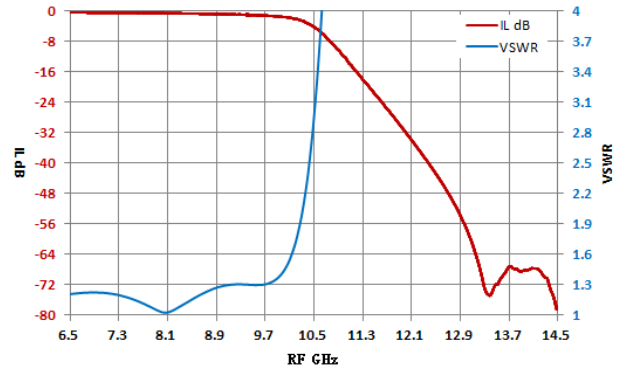


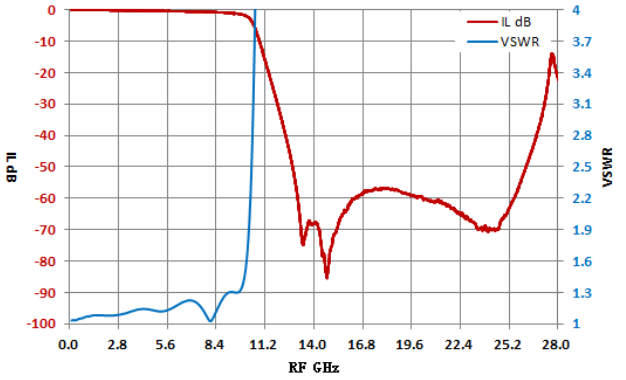
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

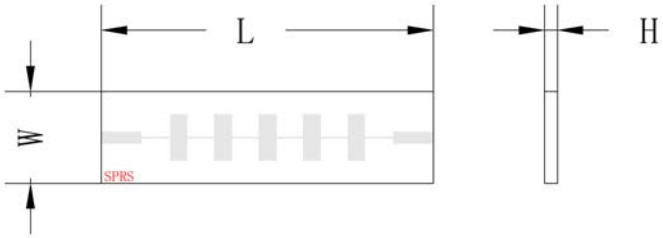
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	5.2	GHz
工作带宽	DC-10.4	GHz
通带损耗	1.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@14.0-27.0GHz	dBc

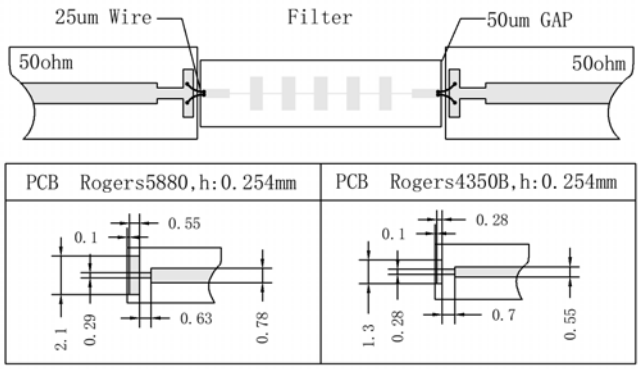
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：4.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

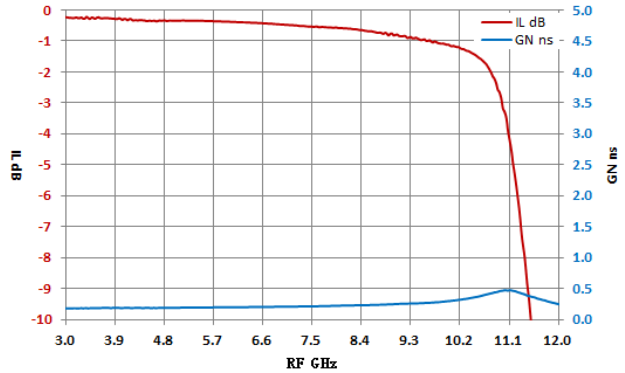
参考实物图

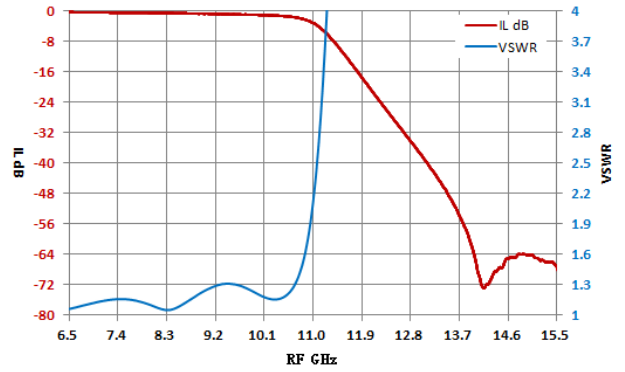


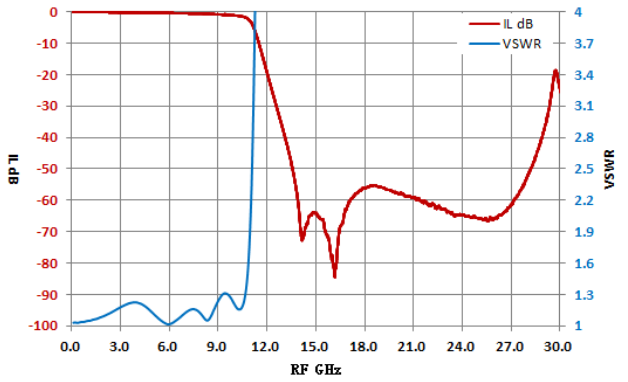
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



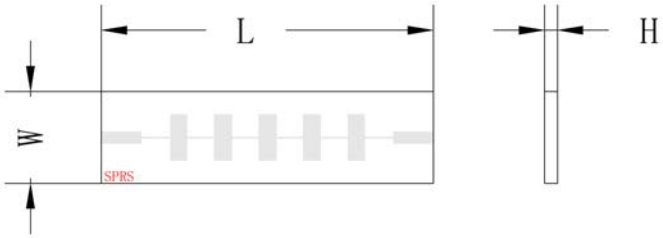
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	5.25	GHz
工作带宽	DC-10.5	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.5	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	30@12.5-21.0GHz	dBc

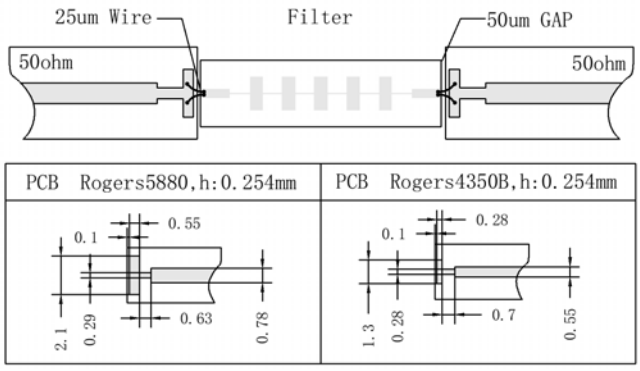
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：5.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



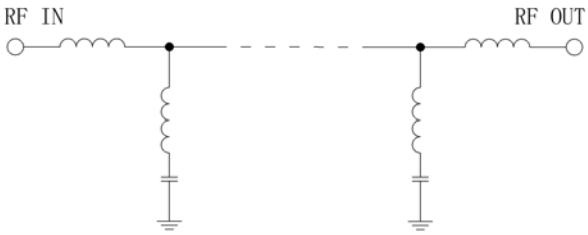
推荐装配图



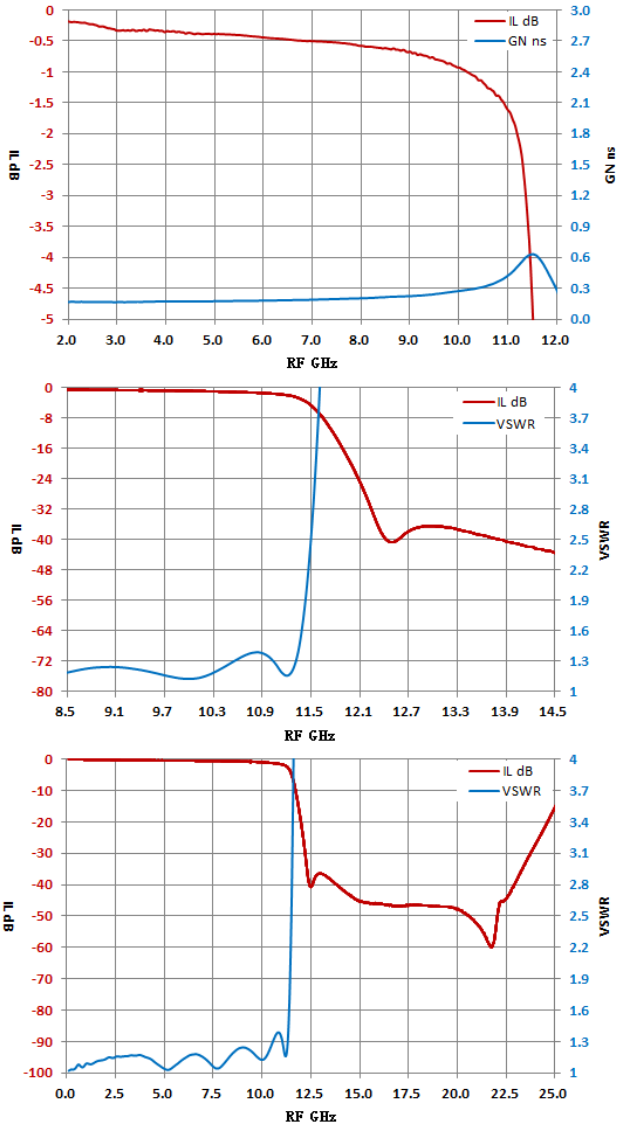
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线



产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

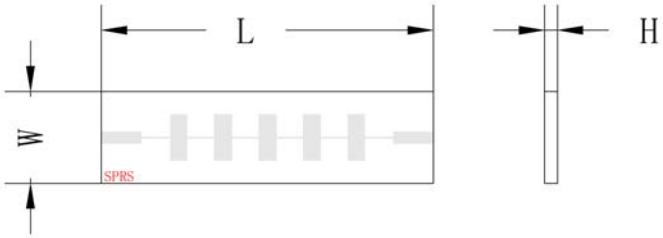
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	5.45	GHz
工作带宽	DC-10.9	GHz
通带损耗	1.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@13.4-25.2GHz	dBc

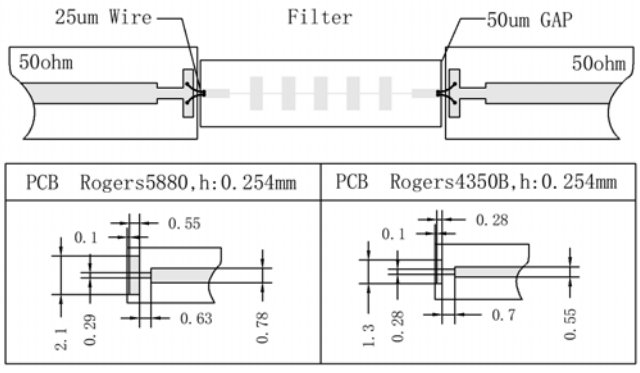
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：4.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

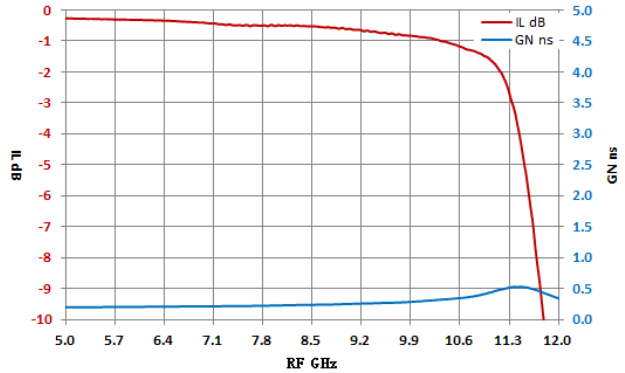
参考实物图

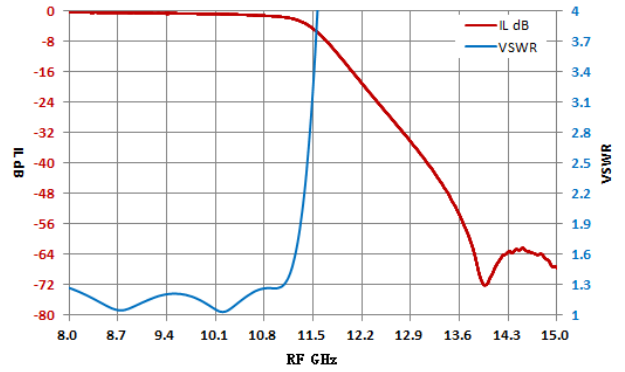


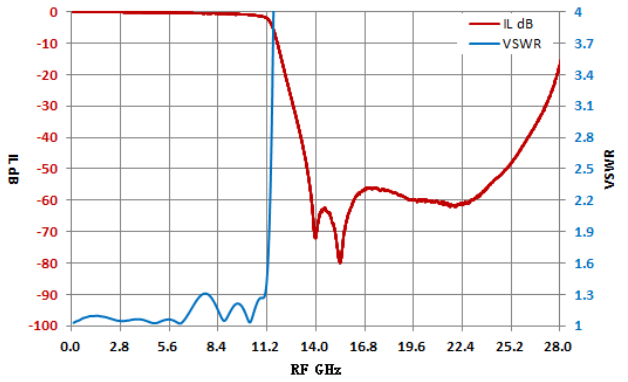
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



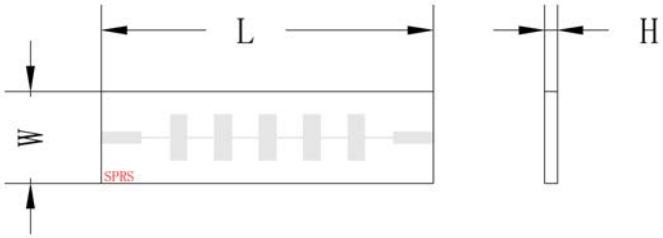
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	5.75	GHz
工作带宽	DC-11.5	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.5	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	25@13.7-23.0GHz	dBc

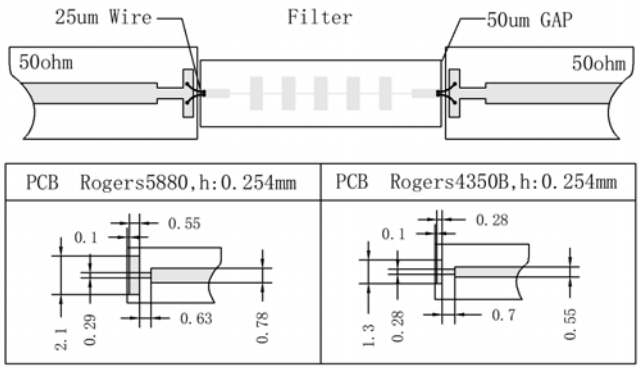
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：4.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



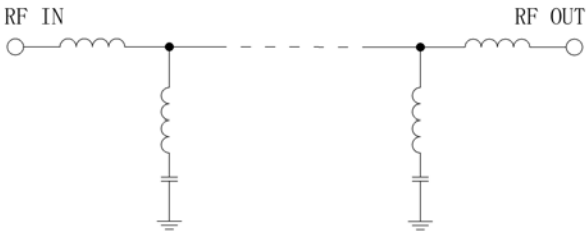
推荐装配图



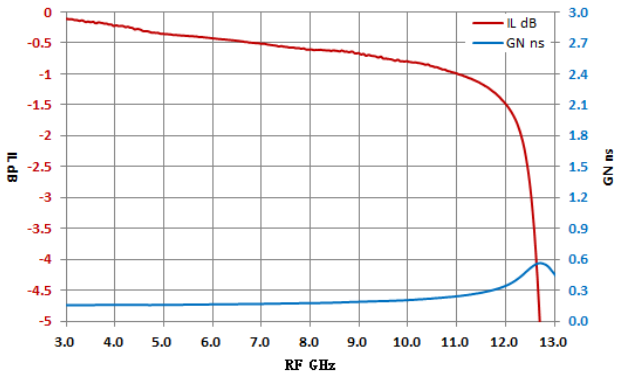
注意事项

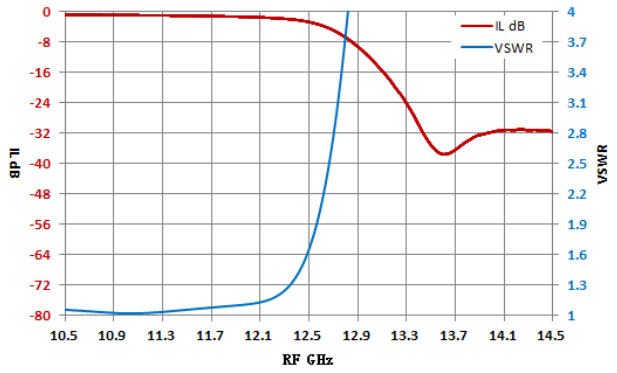
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

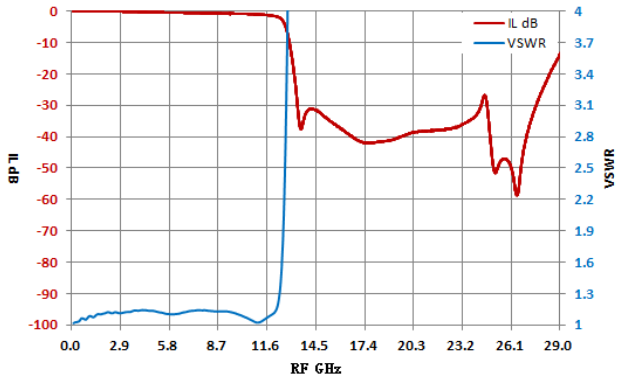
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



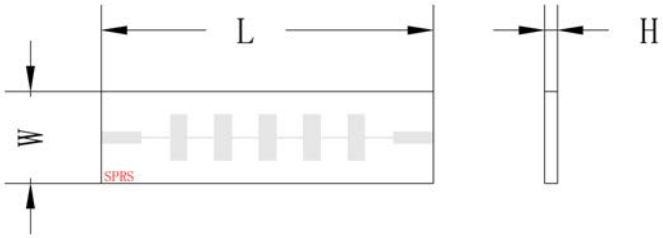
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	5.8	GHz
工作带宽	DC-11.6	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.5	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	35@13.6-25.0GHz	dBc

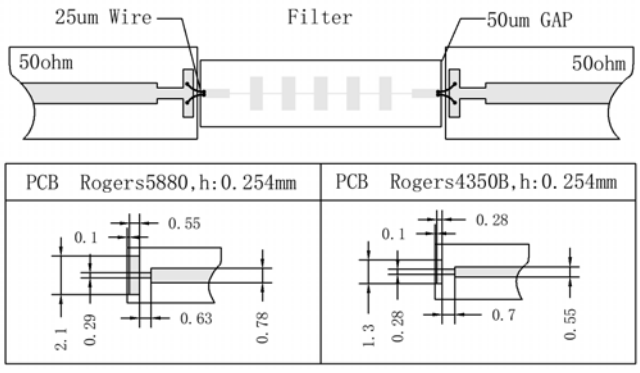
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：2.6，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



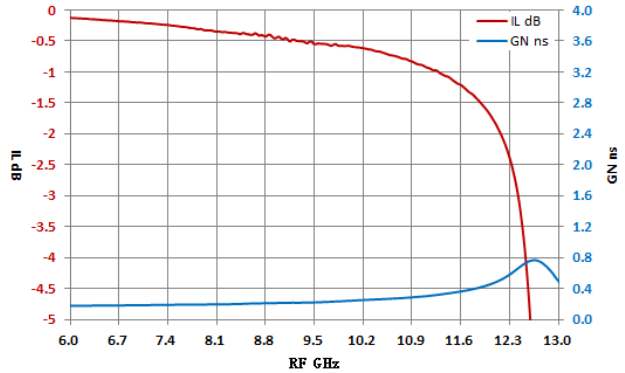
注意事项

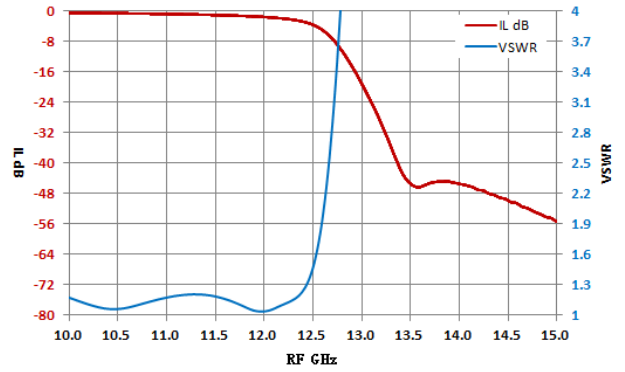
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

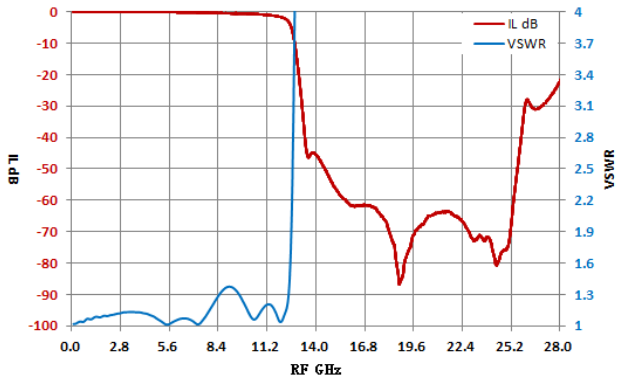
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



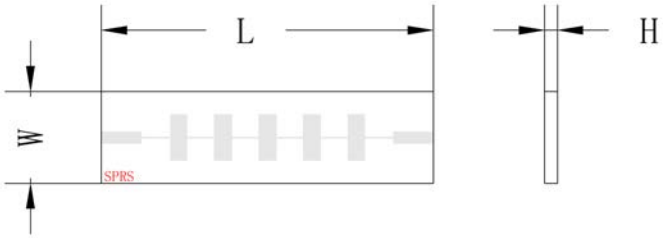
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	5.8	GHz
工作带宽	DC-11.6	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.5	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	38@14.2-23.0GHz	dBc

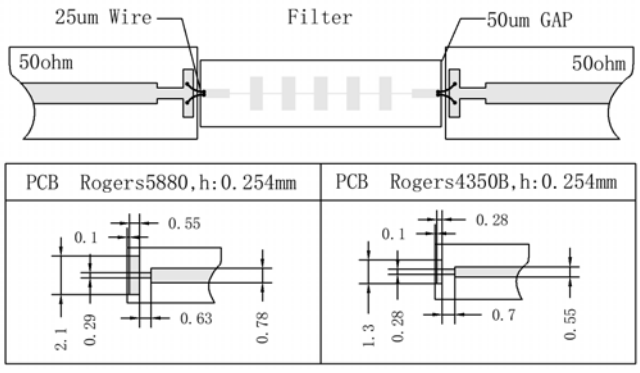
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：5.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



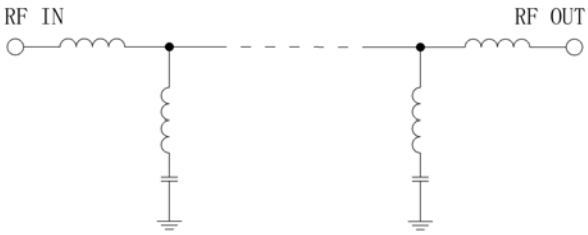
推荐装配图



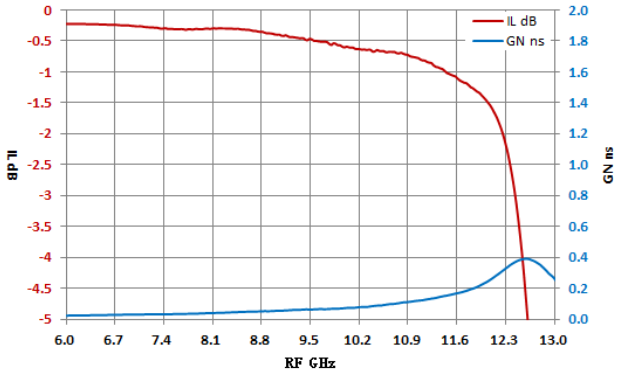
注意事项

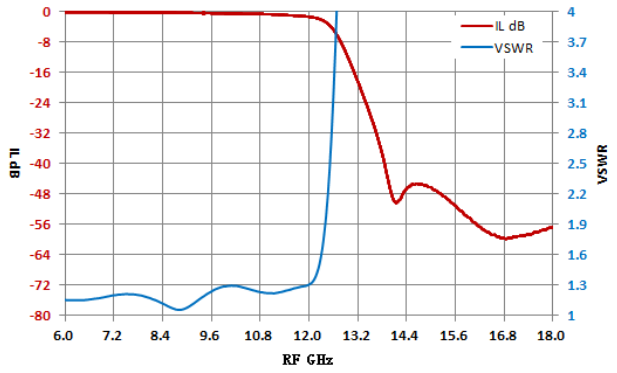
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

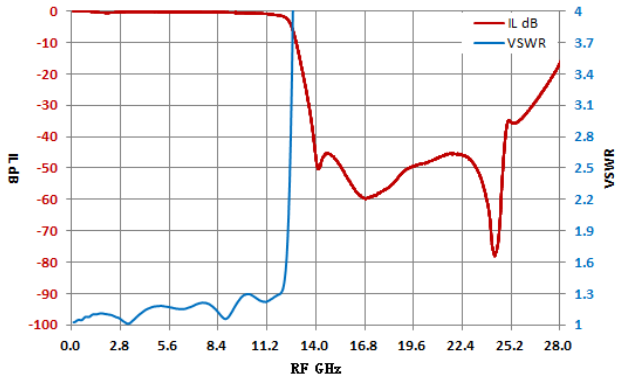
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

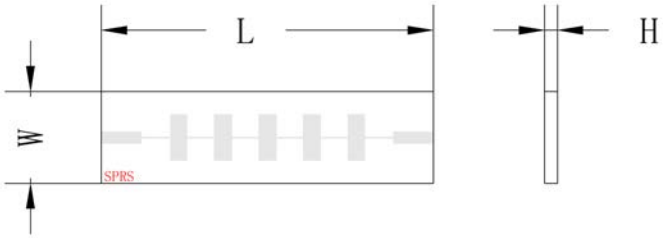
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	5.9	GHz
工作带宽	DC-11.8	GHz
通带损耗	1.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@15.0-28.0GHz	dBc

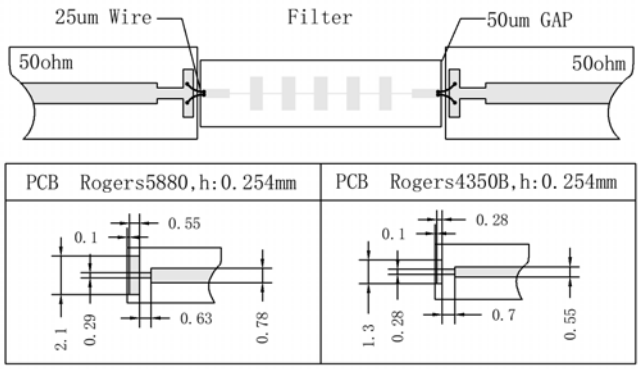
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：4.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

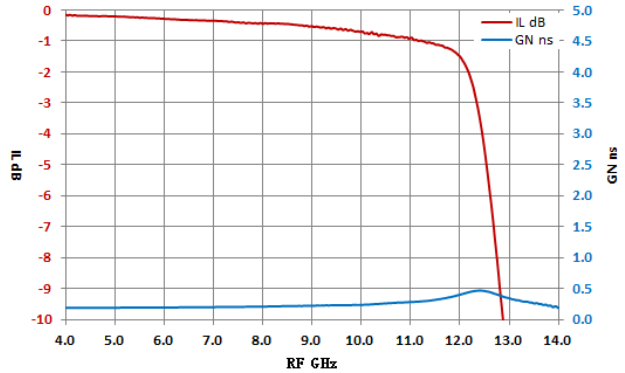
参考实物图

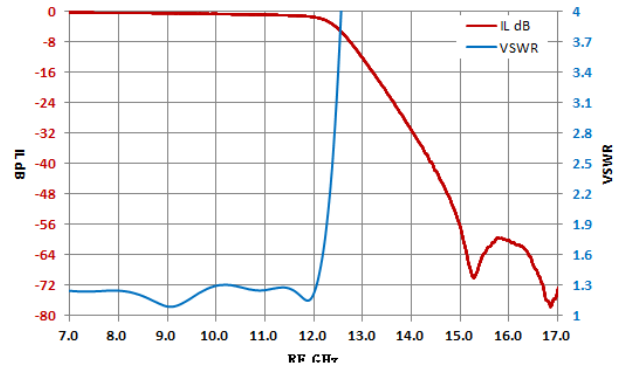


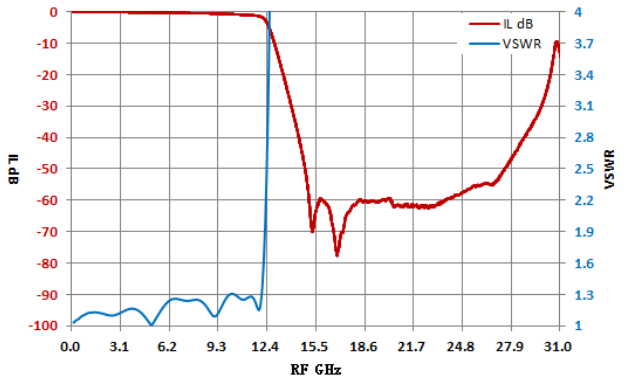
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

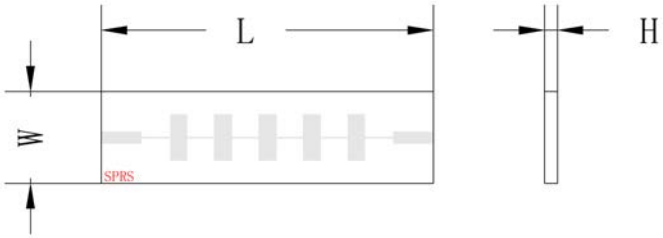
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	6.3	GHz
工作带宽	DC-12.6	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@15.5-30.0GHz	dBc

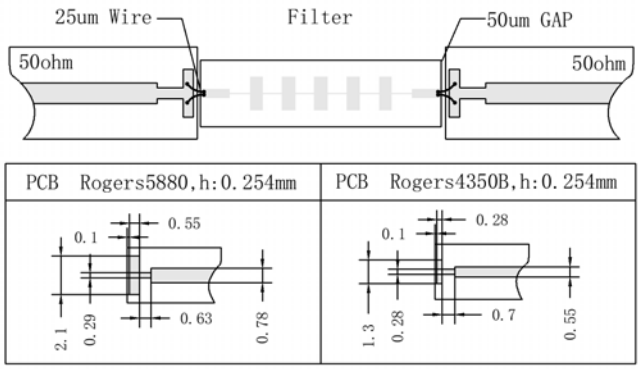
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：4.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

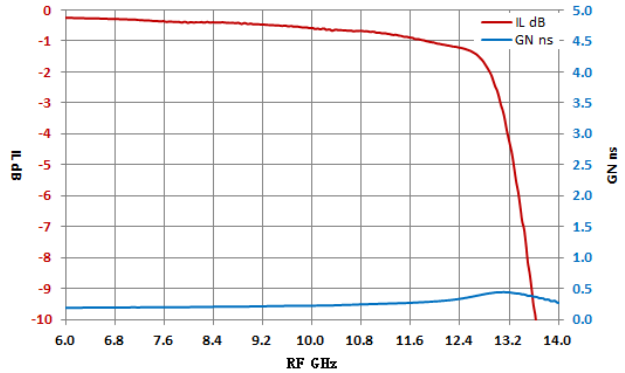
参考实物图

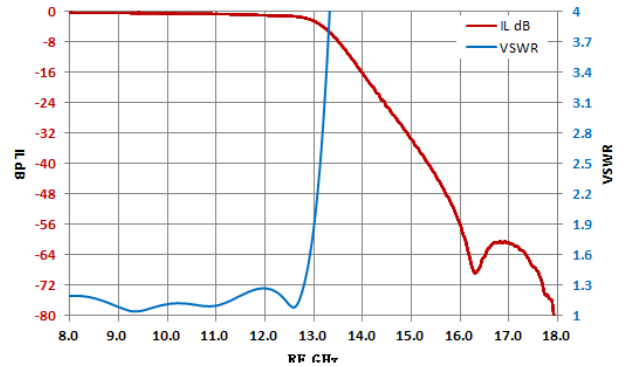


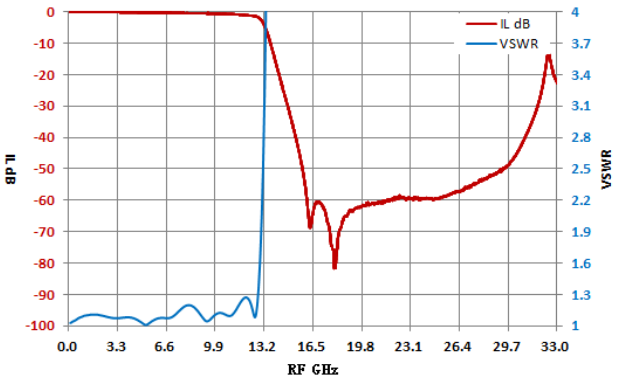
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



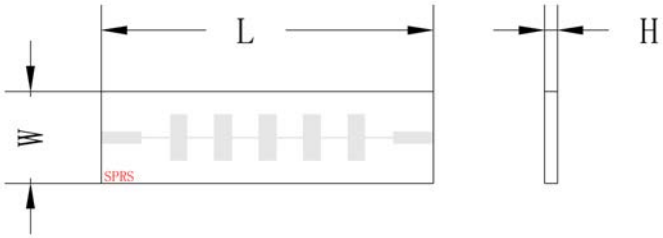
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	6.5	GHz
工作带宽	DC-13.0	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.5	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	30@15.3-26.0GHz	dBc

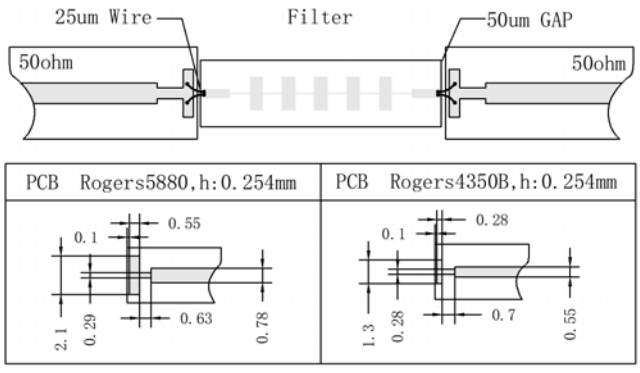
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：4.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



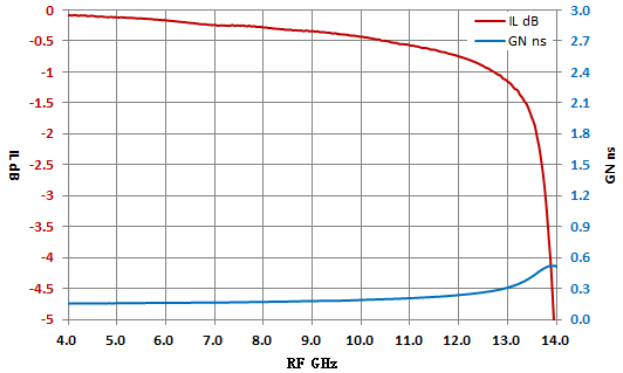
注意事项

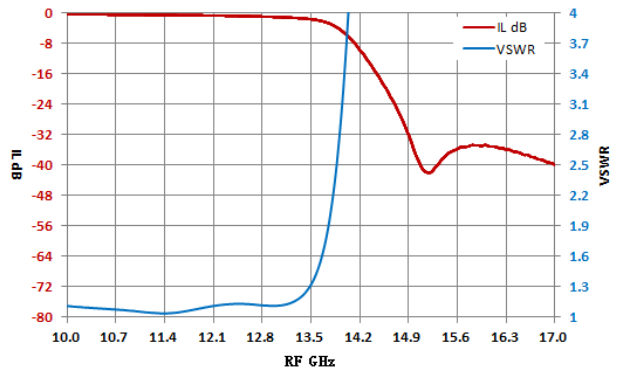
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

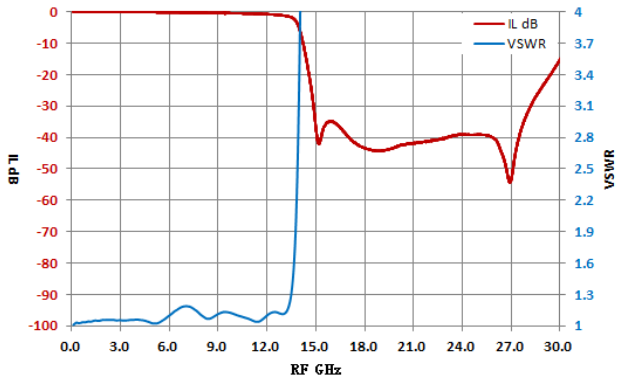
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



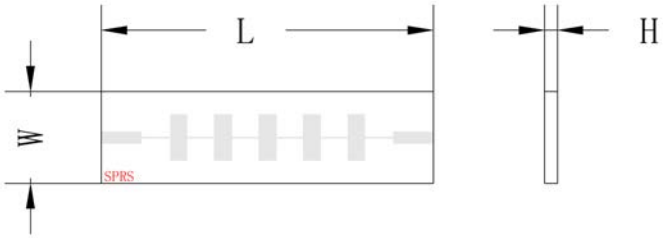
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	6.6	GHz
工作带宽	DC-13.2	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.5	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	25@15.8-26.0GHz	dBc

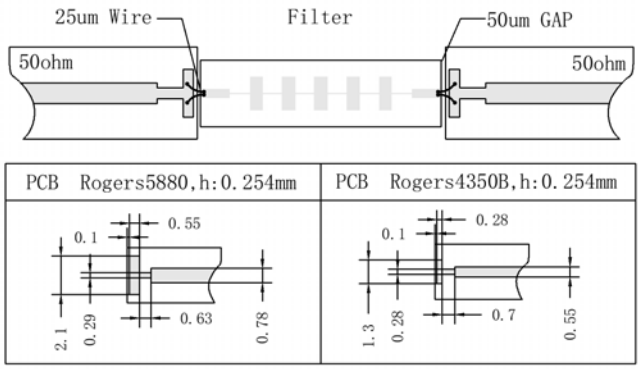
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：4.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



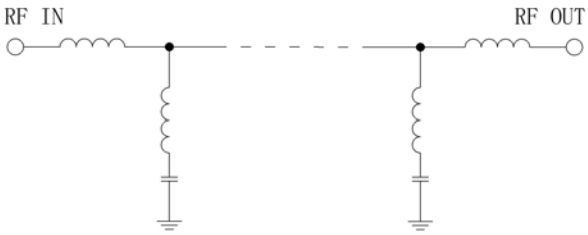
推荐装配图



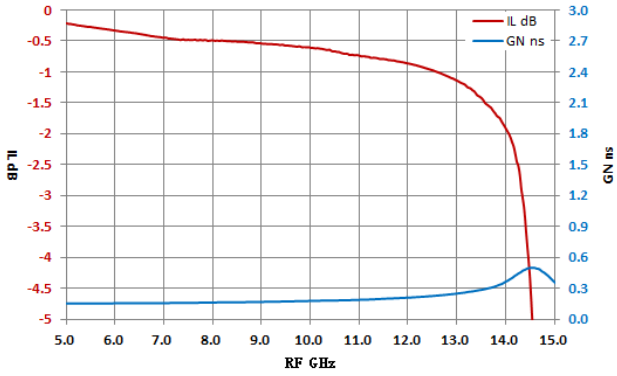
注意事项

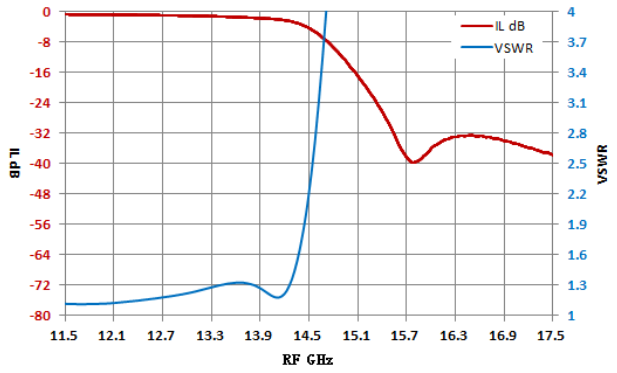
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

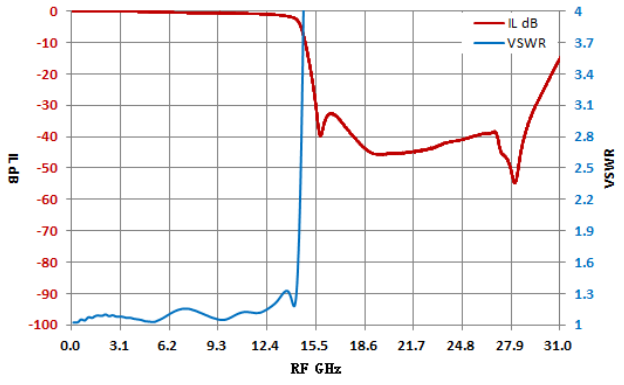
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

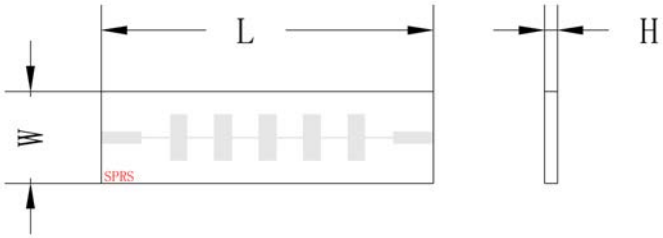
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	6.7	GHz
工作带宽	DC-13.4	GHz
通带损耗	1.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@16.8-30.6GHz	dBc

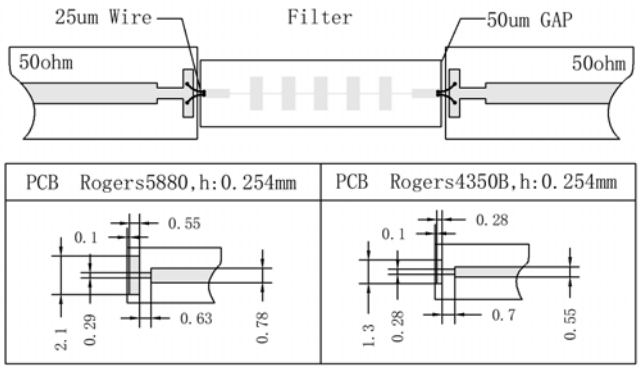
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：4.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

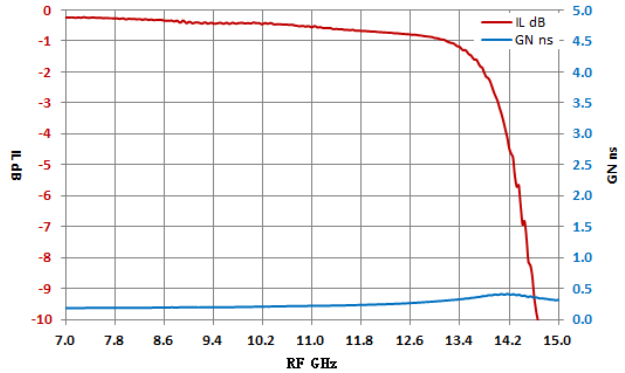
参考实物图

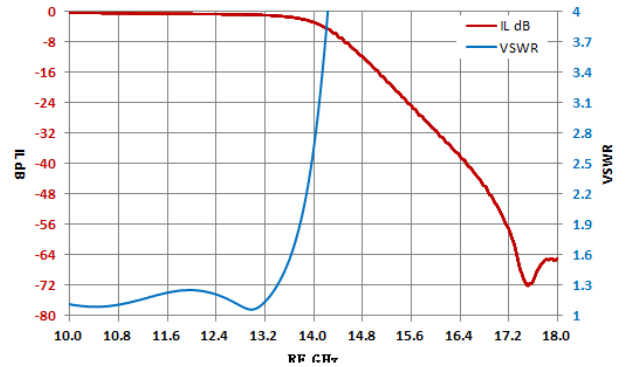


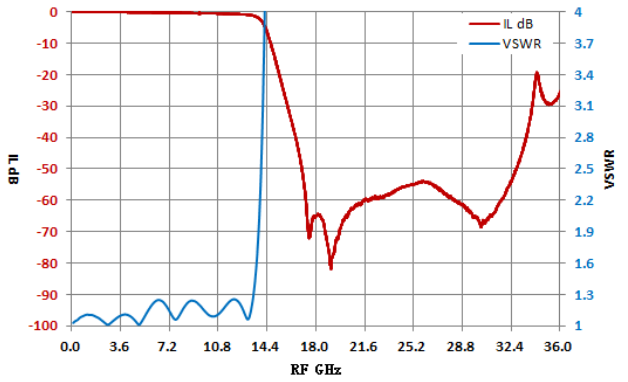
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



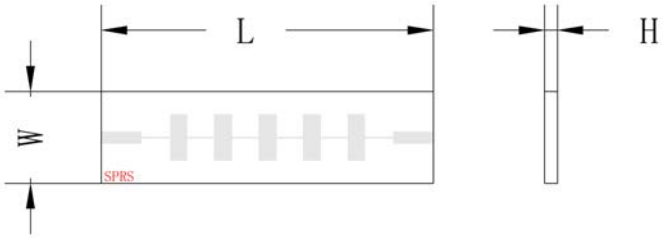
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	7.0	GHz
工作带宽	DC-14.0	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.5	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	30@16.8-28.0GHz	dBc

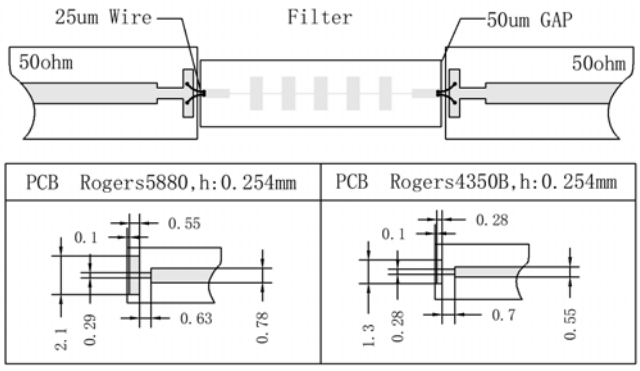
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：4.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



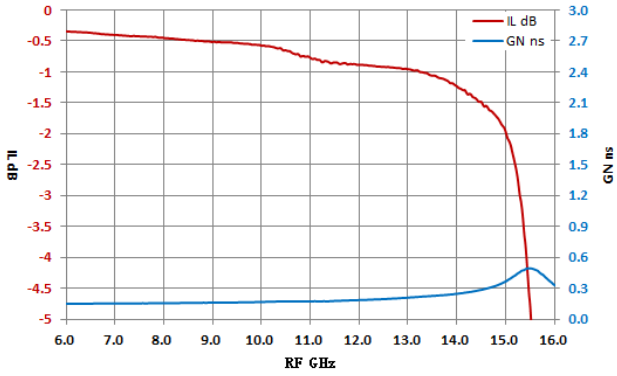
注意事项

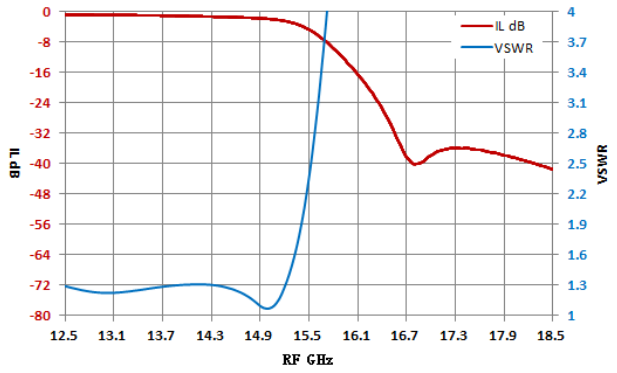
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

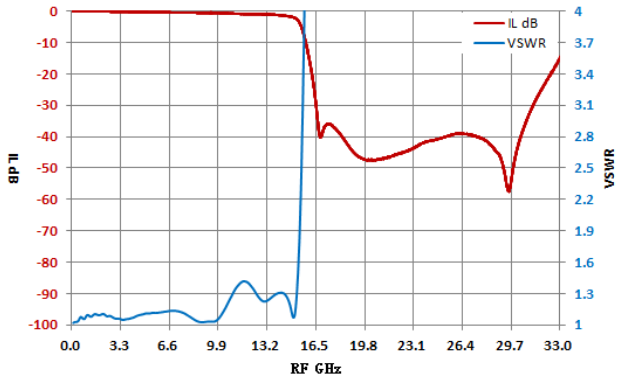
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

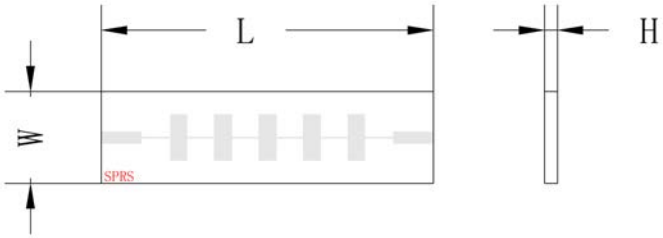
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	7.1	GHz
工作带宽	DC-14.2	GHz
通带损耗	1.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@18.0-34.0GHz	dBc

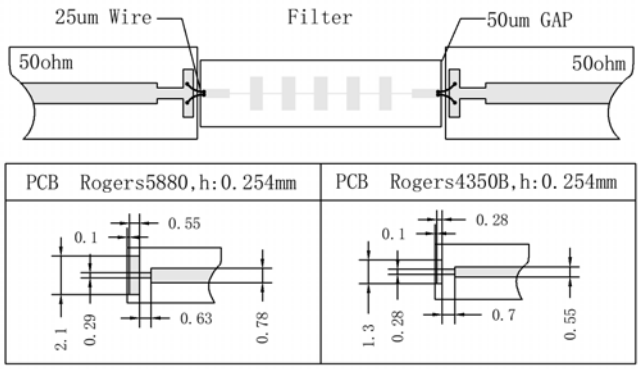
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：4.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

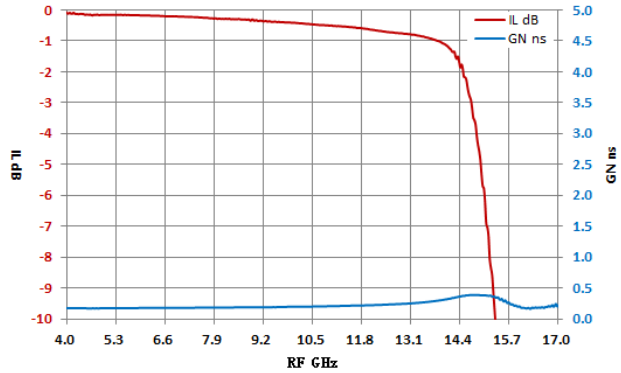
参考实物图

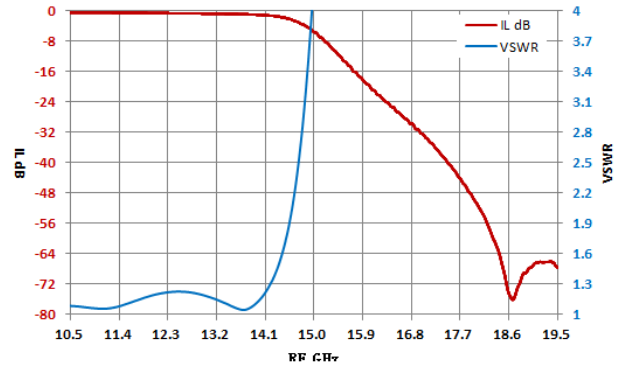


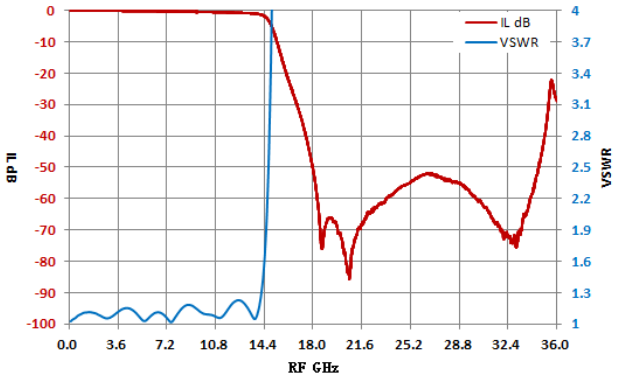
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



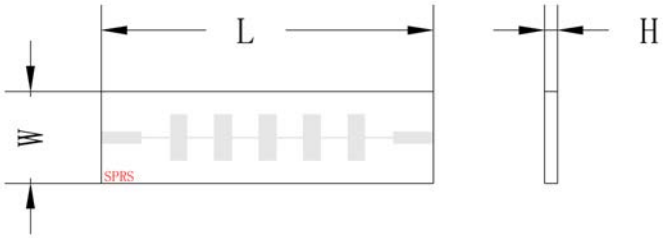
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	7.3	GHz
工作带宽	DC-14.6	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.5	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	1.2	ns
带外抑制	30@20.5-40.0GHz	dBc

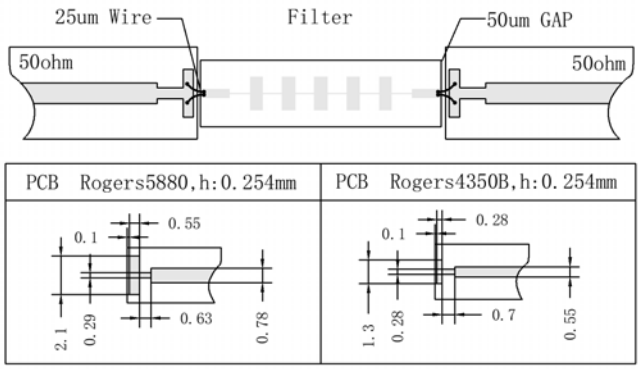
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



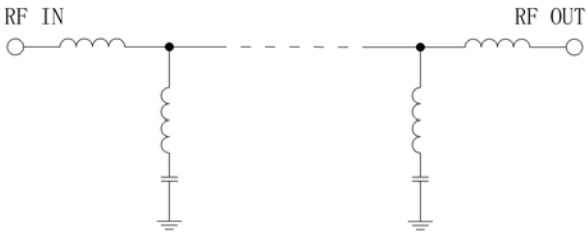
推荐装配图



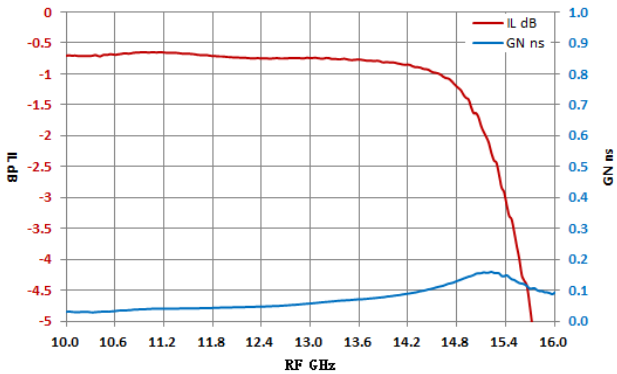
注意事项

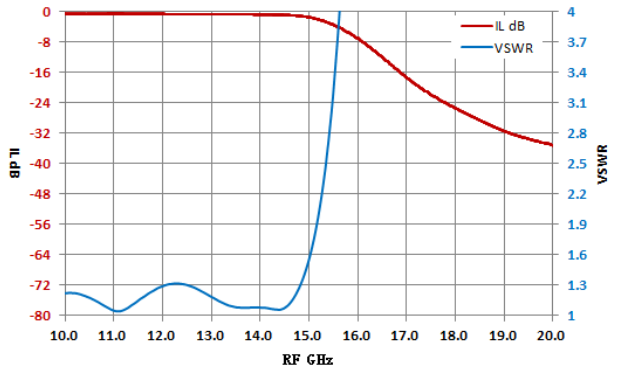
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

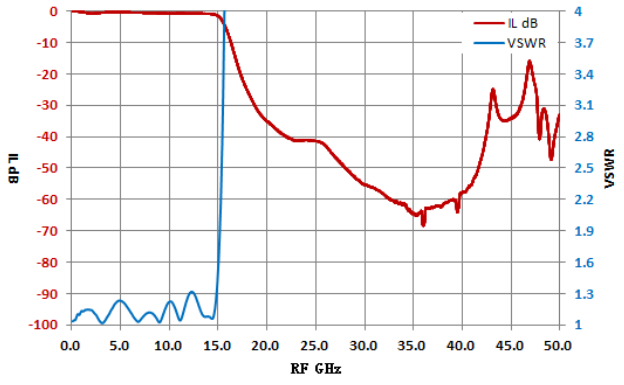
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



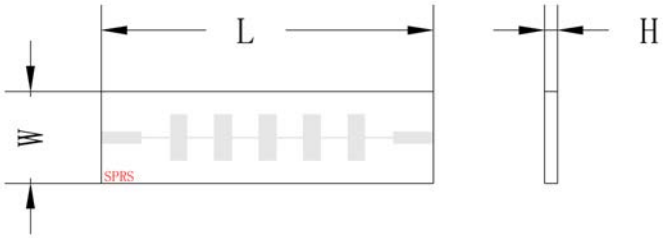
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	7.4	GHz
工作带宽	DC-14.8	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.5	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	25@18.0-31.0GHz	dBc

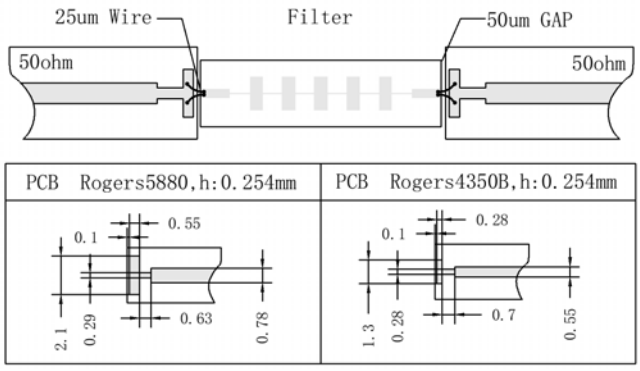
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：4.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



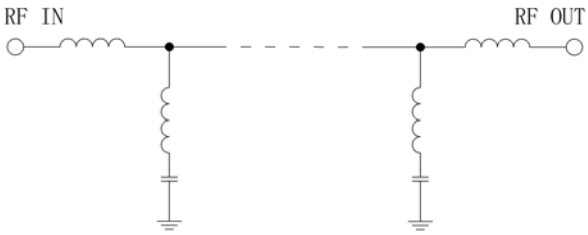
推荐装配图



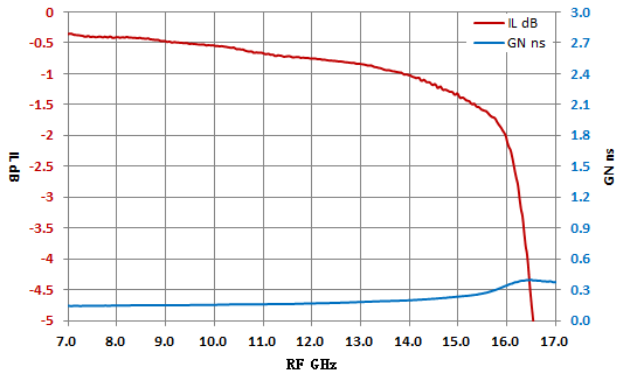
注意事项

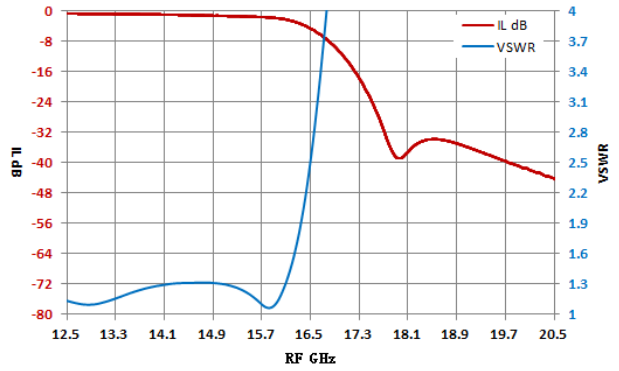
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

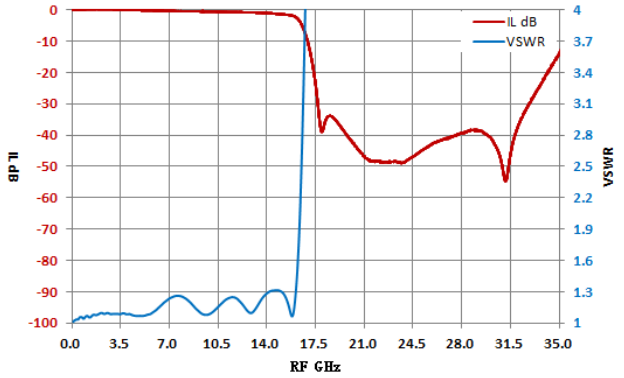
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

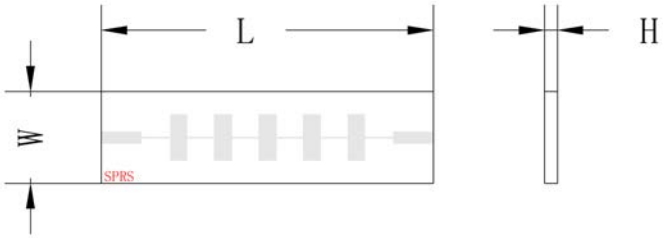
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	7.5	GHz
工作带宽	DC-15.0	GHz
通带损耗	1.4	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@DC-6.0GHz	dBc

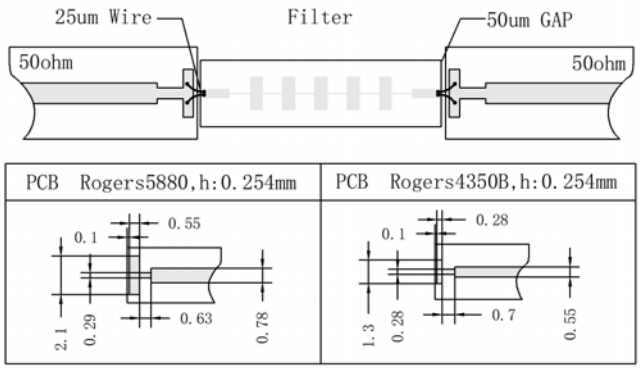
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：4.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

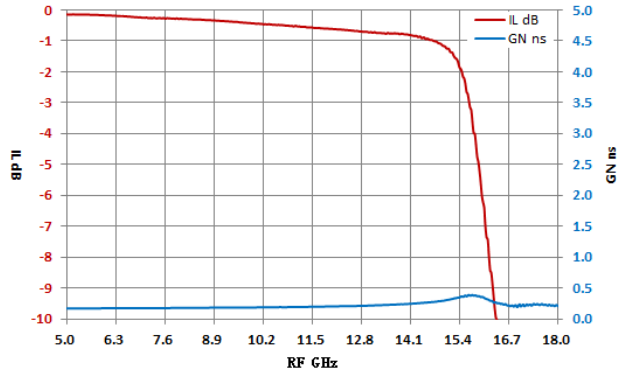
参考实物图

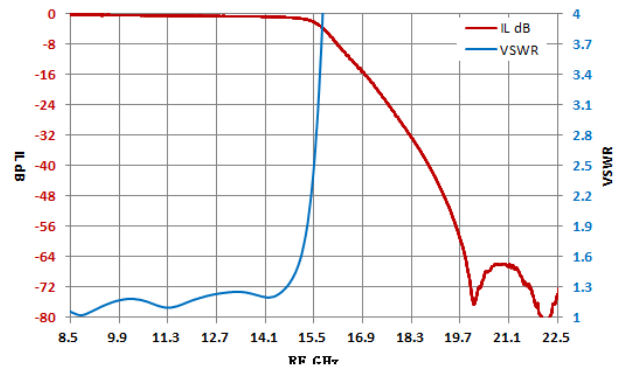


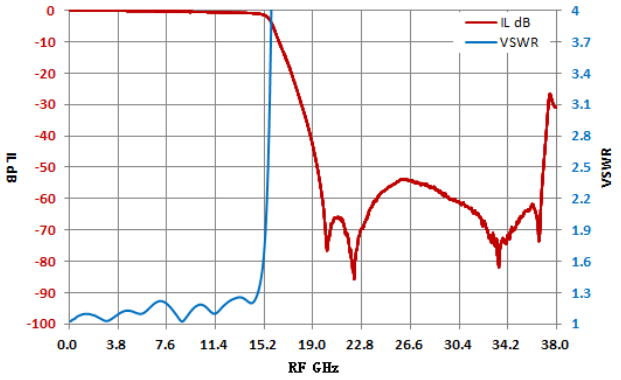
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

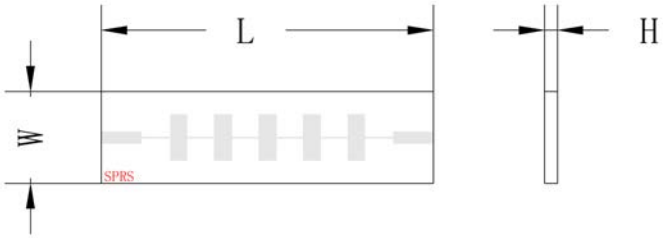
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	7.6	GHz
工作带宽	DC-15.2	GHz
通带损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@18.8-29.0GHz	dBc

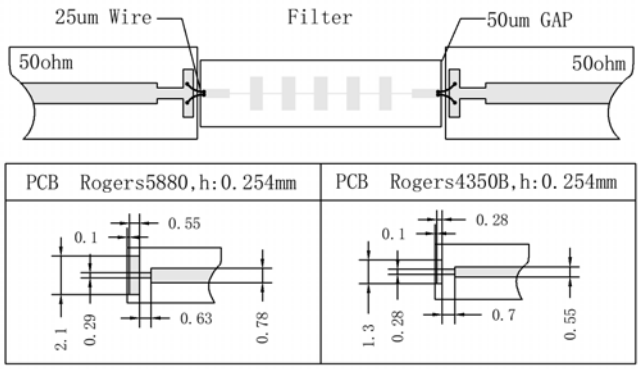
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：3.5，W：1.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

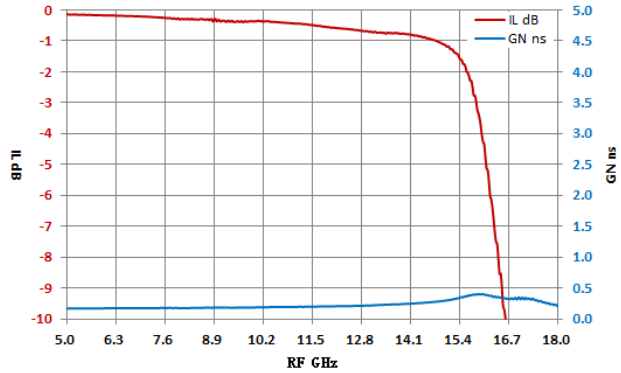
参考实物图

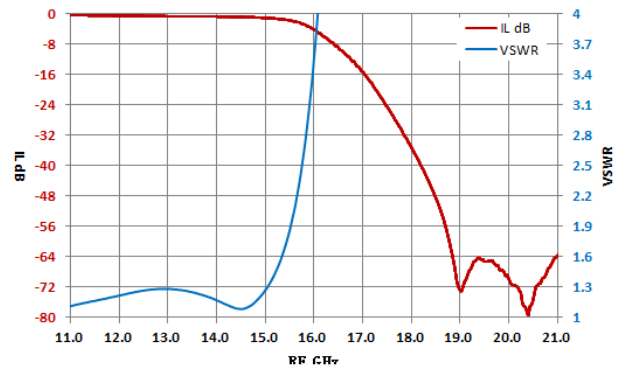


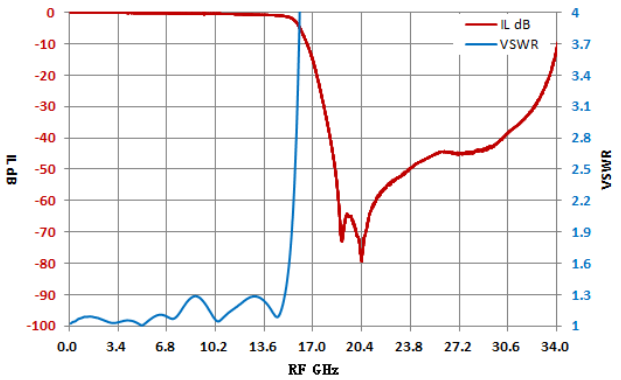
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



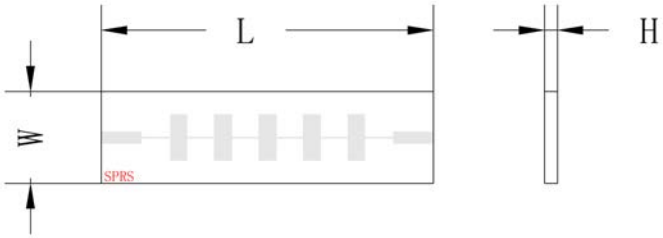
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	8.0	GHz
工作带宽	DC-16.0	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.5	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	1.5	ns
带外抑制	30@19.7-33.0GHz	dBc

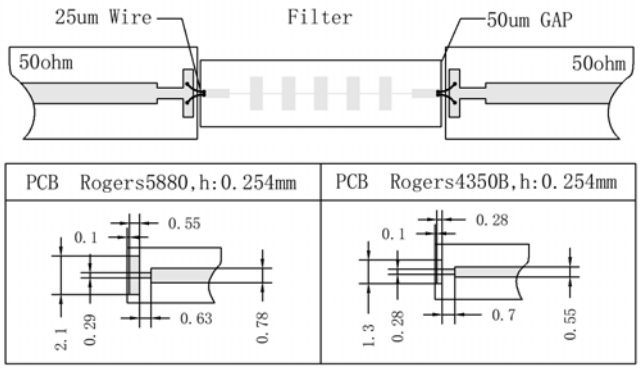
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：4.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



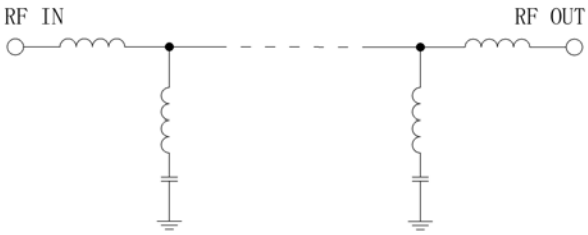
推荐装配图



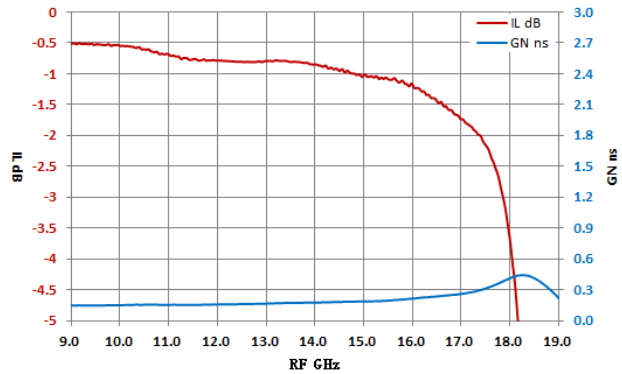
注意事项

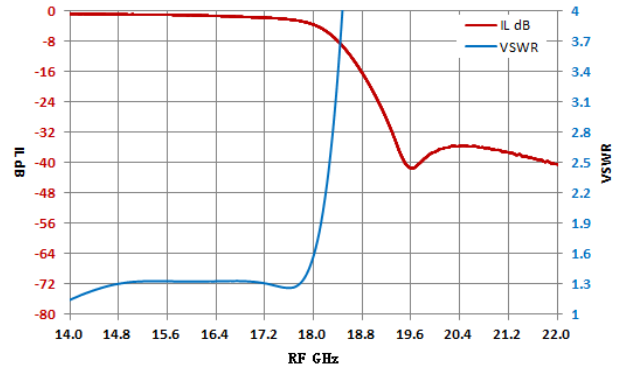
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

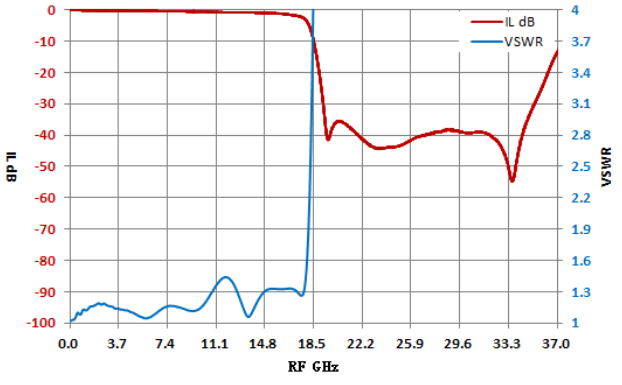
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

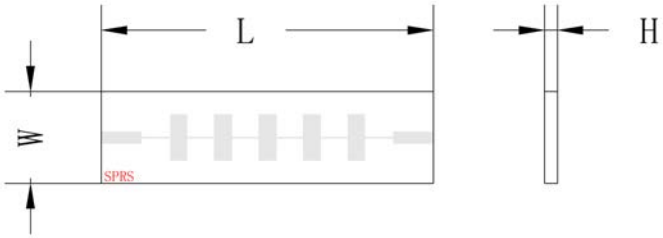
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	8.3	GHz
工作带宽	DC-16.6	GHz
通带损耗	2.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@20.7-35.0GHz	dBc

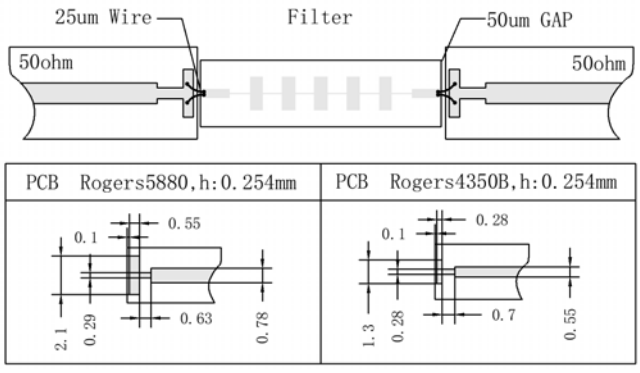
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：3.5，W：1.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

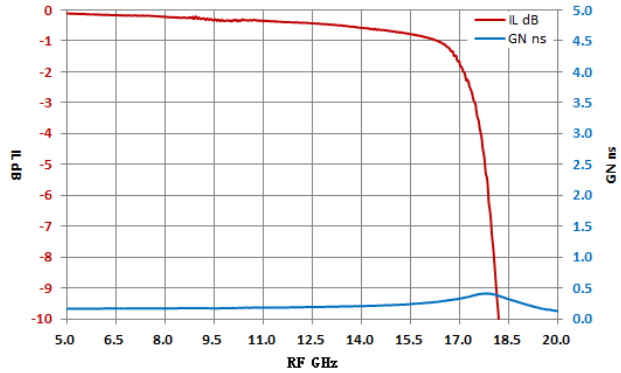
参考实物图

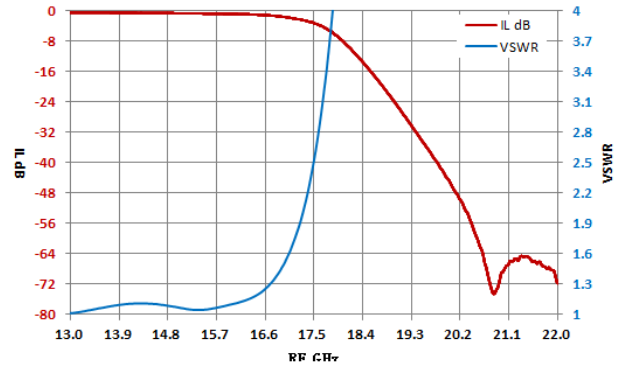


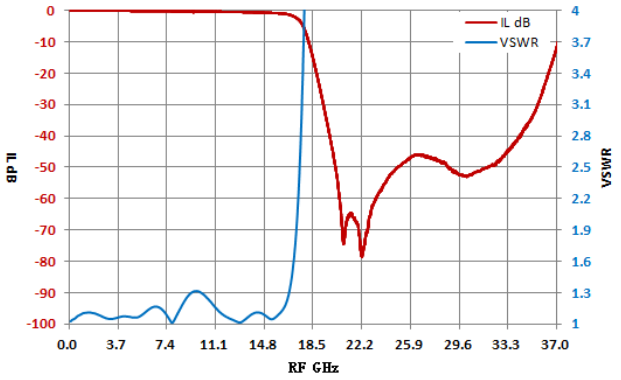
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



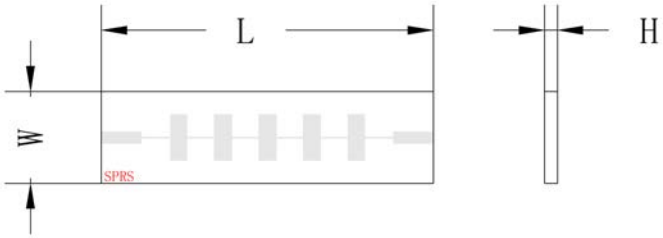
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	8.4	GHz
工作带宽	DC-16.8	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.5	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	1.0	ns
带外抑制	30@19.9-33.0GHz	dBc

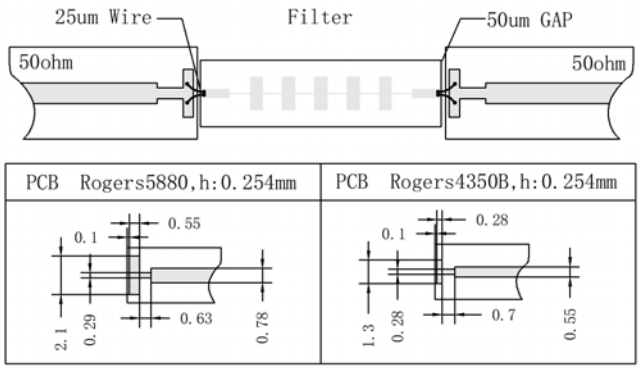
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：4.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



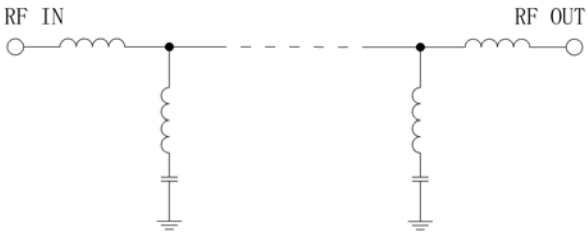
推荐装配图



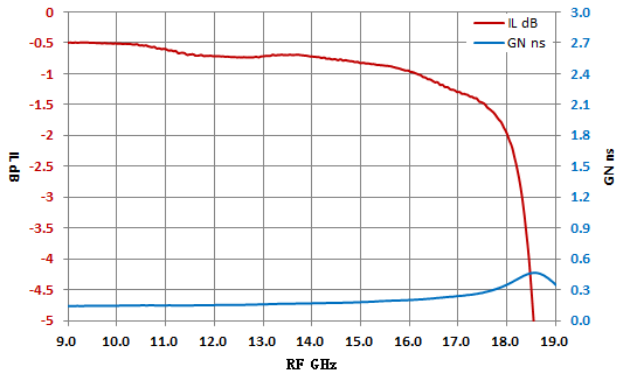
注意事项

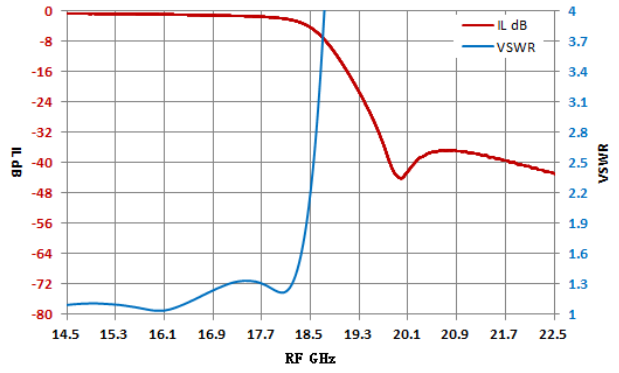
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

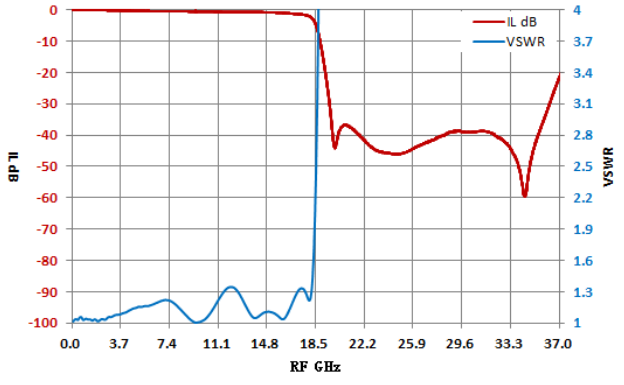
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



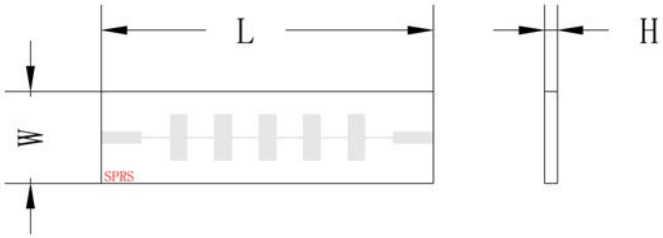
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	8.5	GHz
工作带宽	DC-17.0	GHz
通带损耗	2.0	dB
带内波动	2.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	30@19.9-48.0GHz	dBc

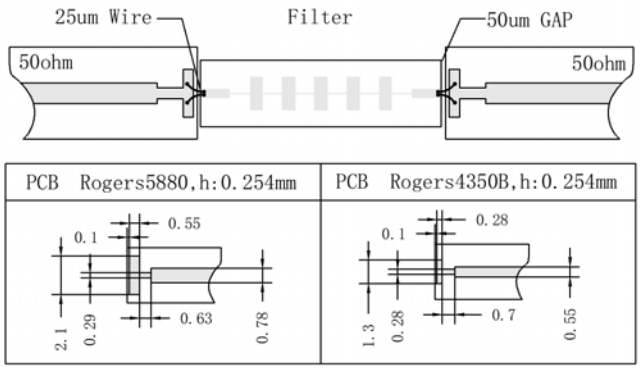
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



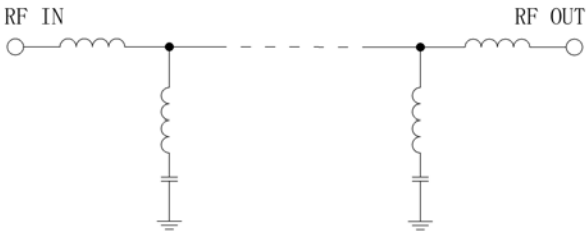
推荐装配图



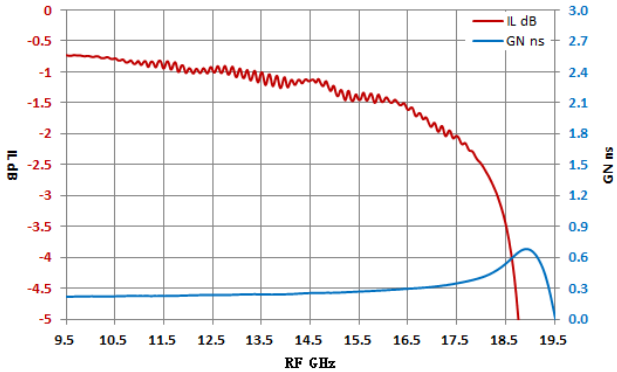
注意事项

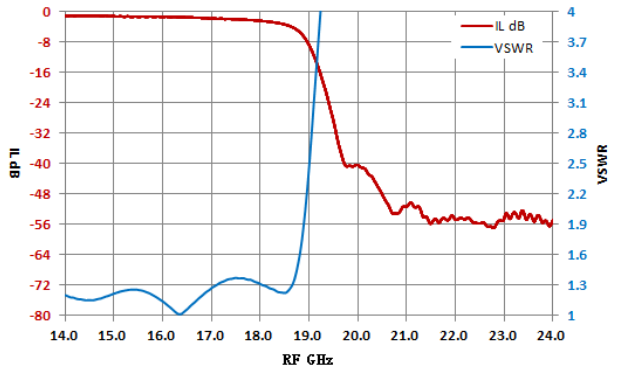
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

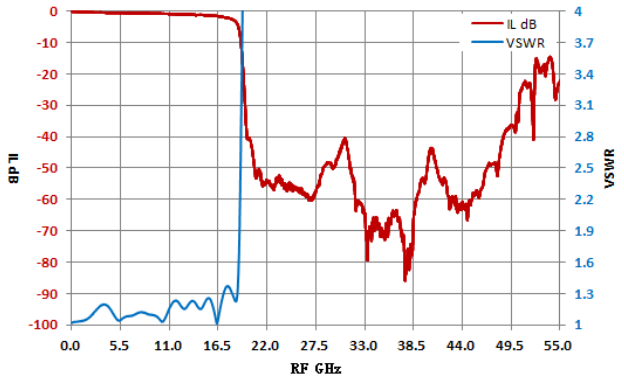
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



技术要求

项目	参数	单位
中心频率	8.6	GHz
工作带宽	DC-17.2	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.5	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	30@20.5-39.0GHz	dBc

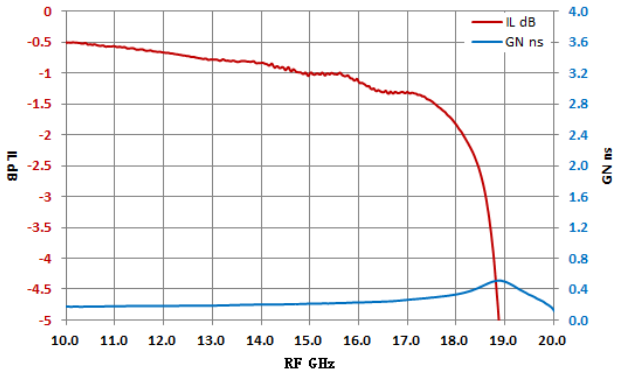
原理图

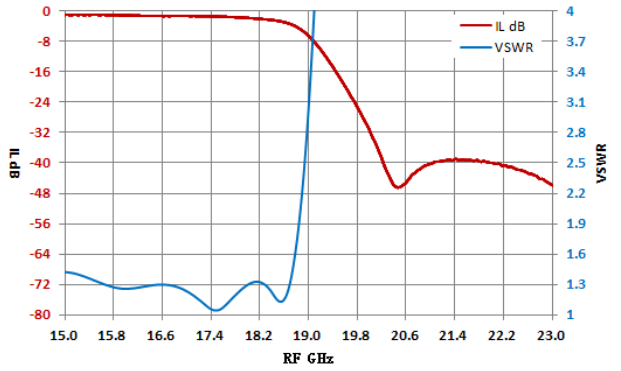


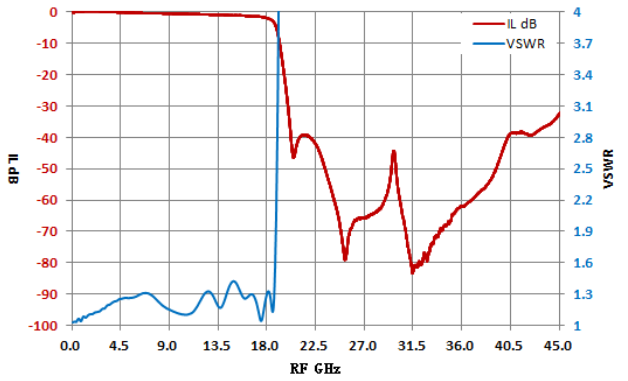
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.0，h：0.26

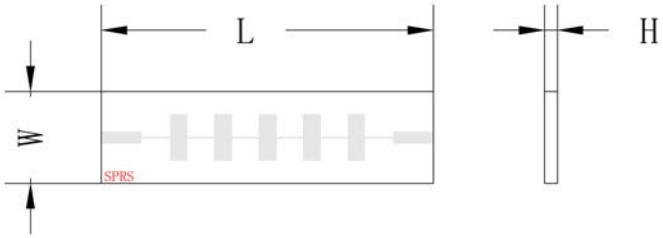
典型曲线



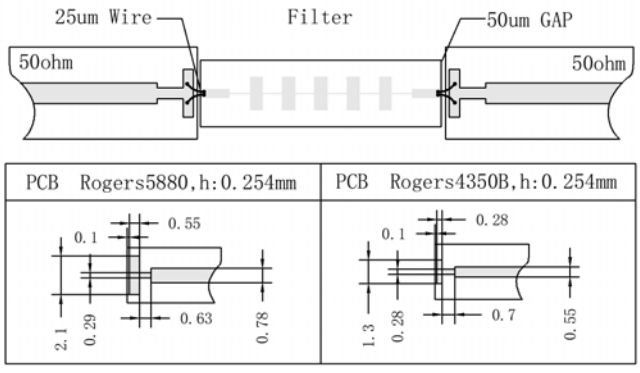




外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

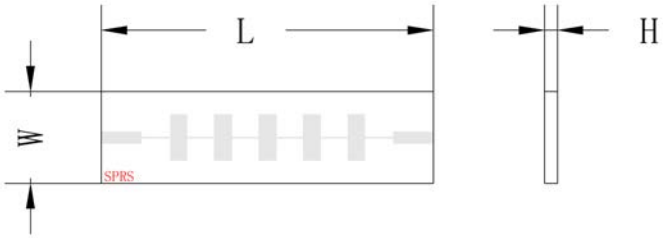
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	8.65	GHz
工作带宽	DC-17.3	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@21.0-34.2GHz	dBc

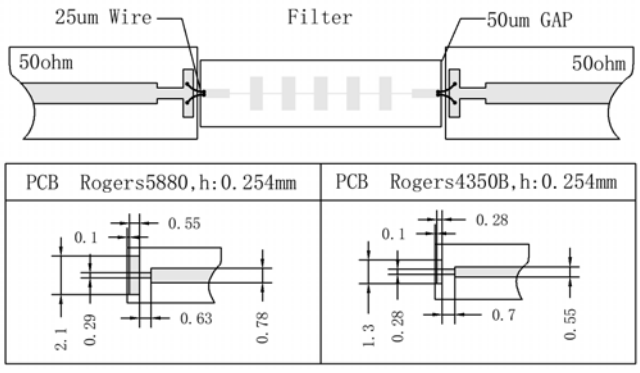
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：3.0，W：1.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

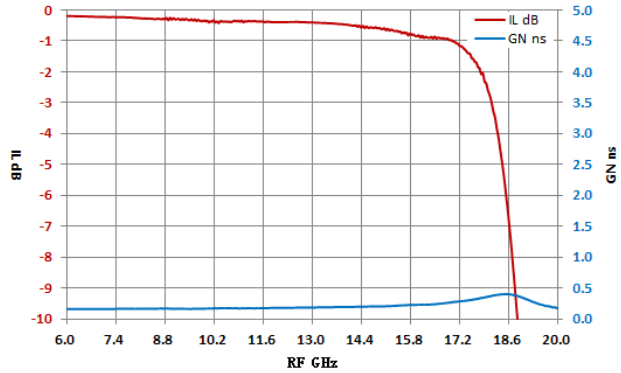
参考实物图

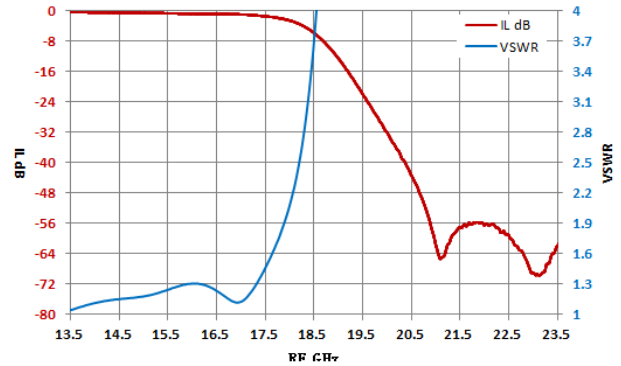


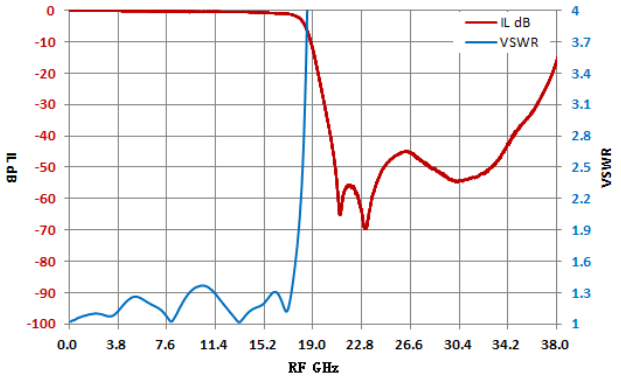
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



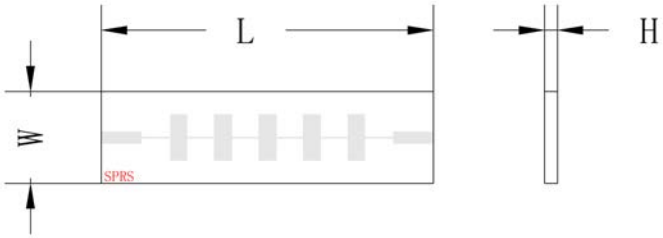
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	8.7	GHz
工作带宽	DC-17.4	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.5	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@21.6-38.0GHz	dBc

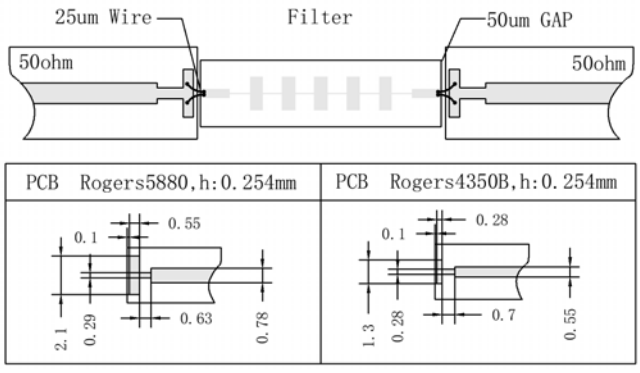
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：8.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



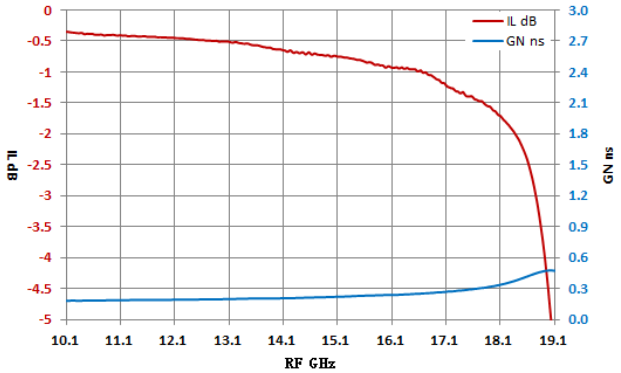
注意事项

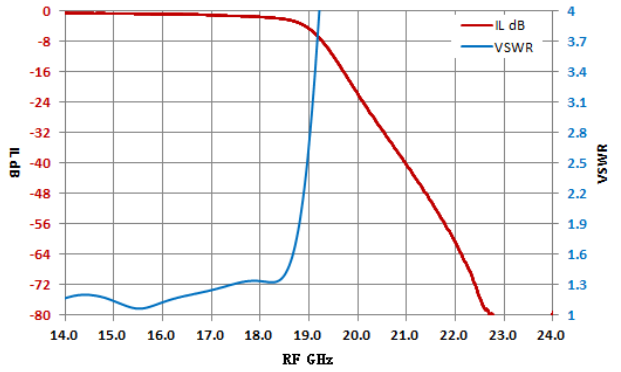
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

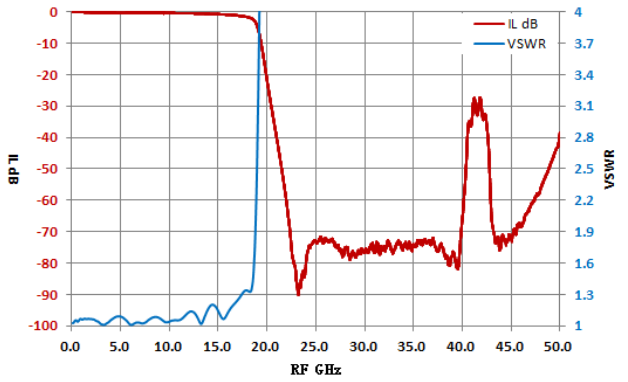
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



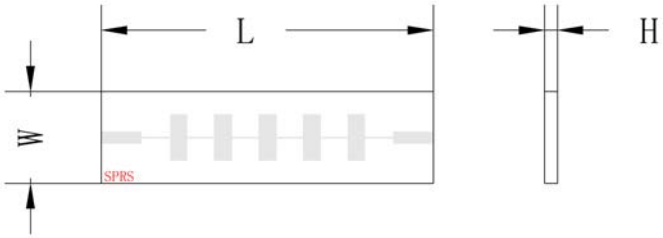
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.0	GHz
工作带宽	DC-18.0	GHz
通带损耗	2.0	dB
带内波动	2.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	25@20.3-34.0GHz	dBc

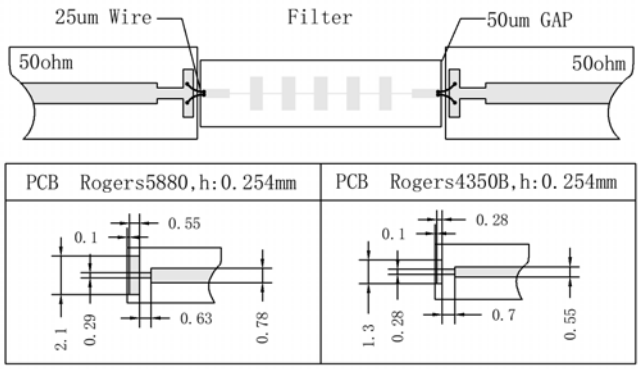
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：3.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



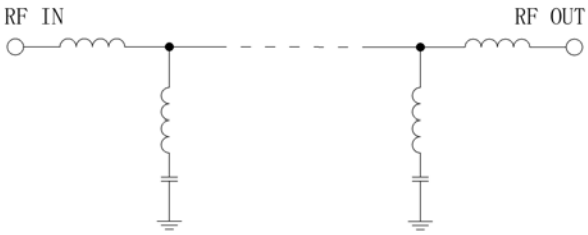
推荐装配图



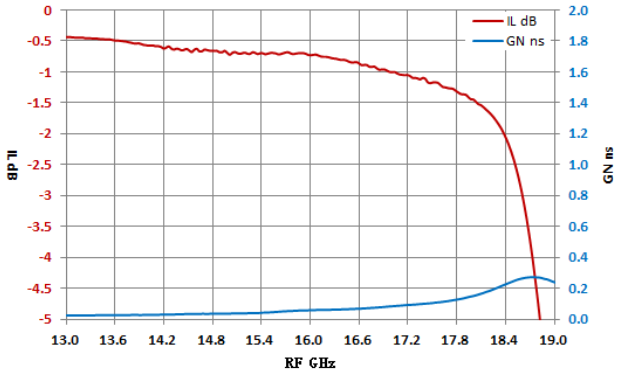
注意事项

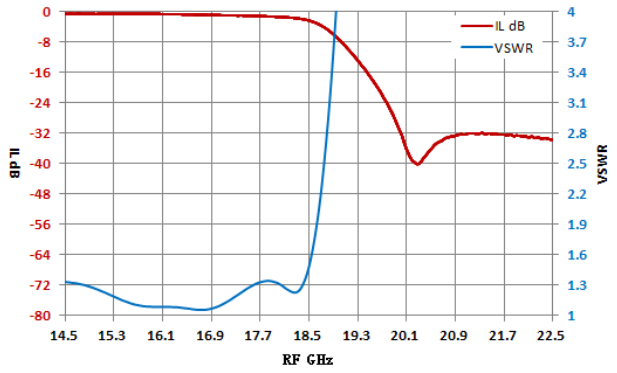
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

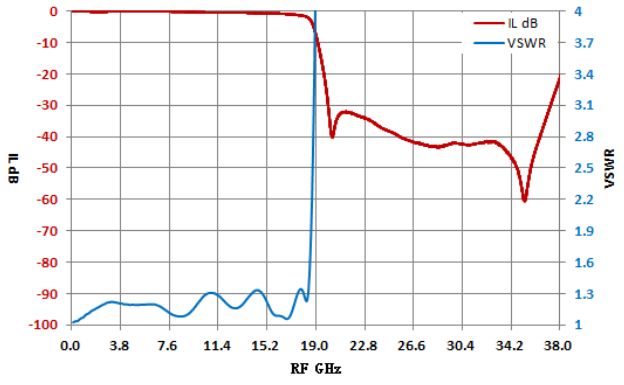
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



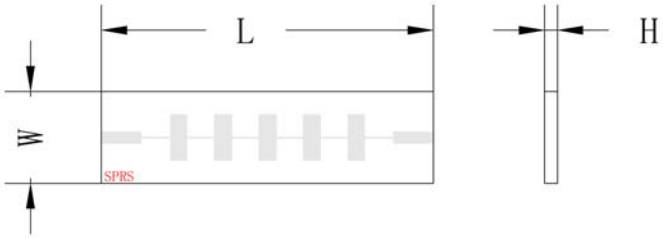
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.0	GHz
工作带宽	DC-18.0	GHz
通带损耗	2.0	dB
带内波动	2.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	35@21.7-32.0GHz	dBc

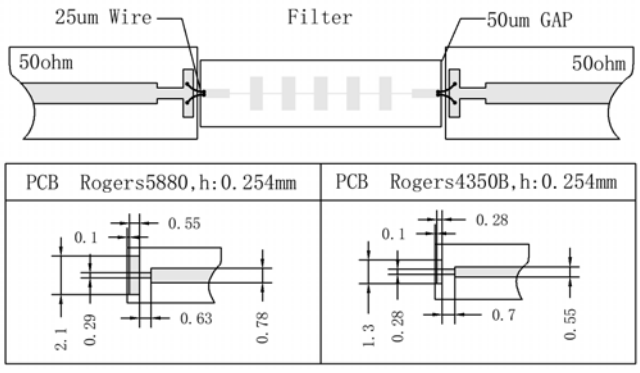
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：3.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



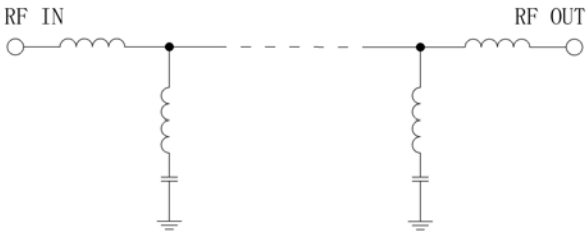
推荐装配图



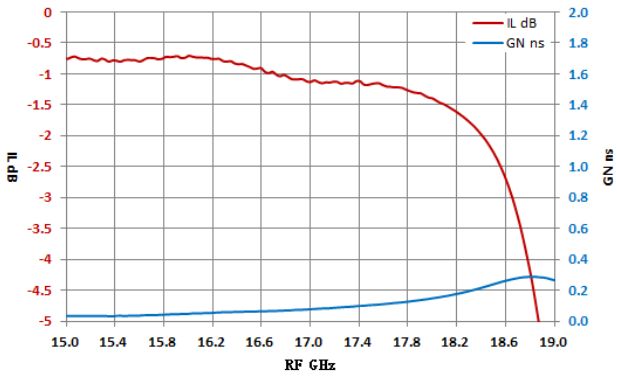
注意事项

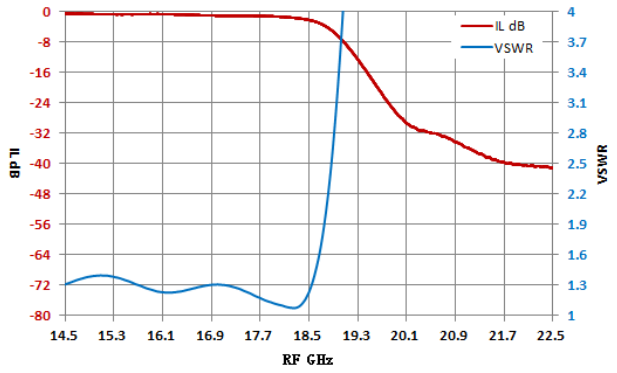
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

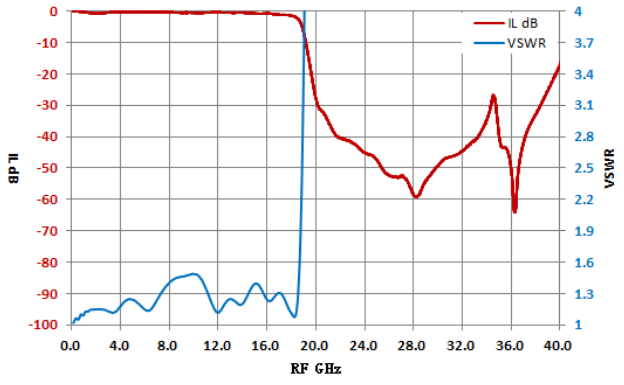
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



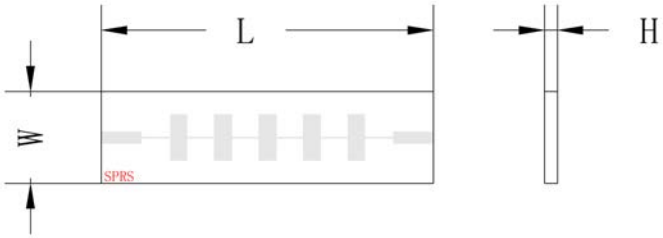
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.1	GHz
工作带宽	DC-18.2	GHz
通带损耗	2.0	dB
带内波动	2.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@22.4-33.0GHz	dBc

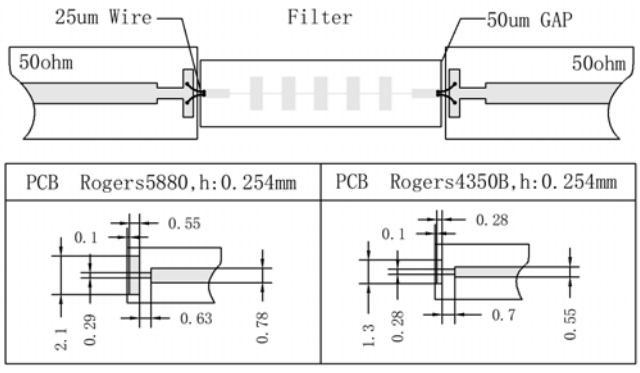
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：7.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



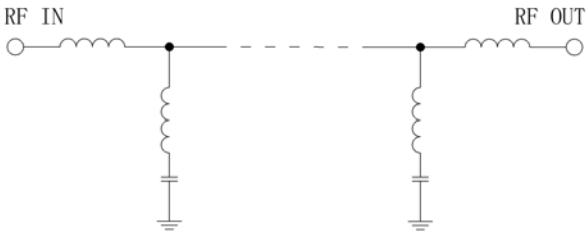
推荐装配图



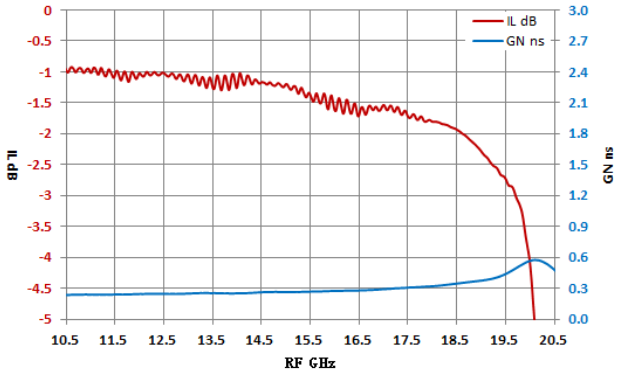
注意事项

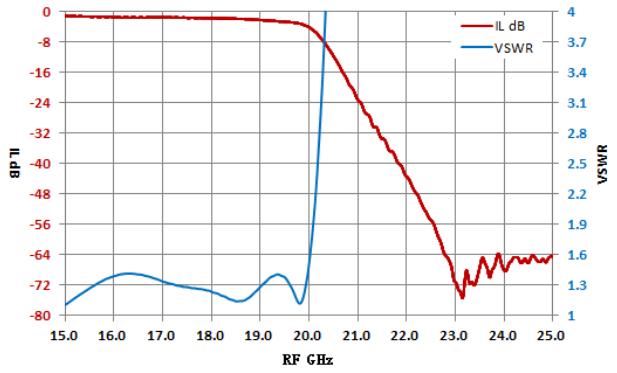
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

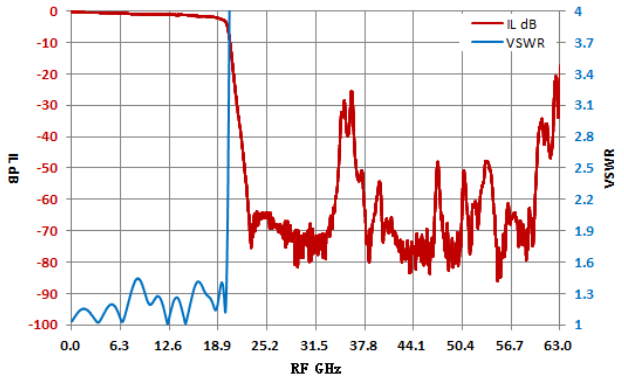
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



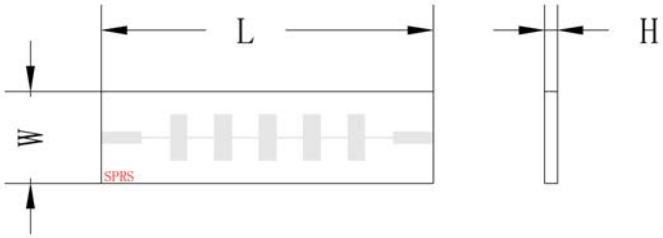
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.3	GHz
工作带宽	DC-18.6	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.5	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	25@21.4-35.0GHz	dBc

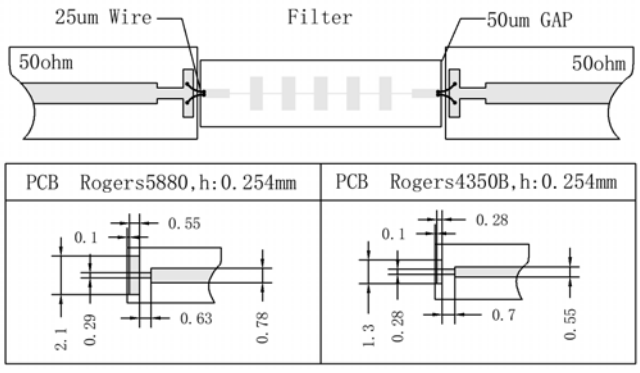
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：4.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



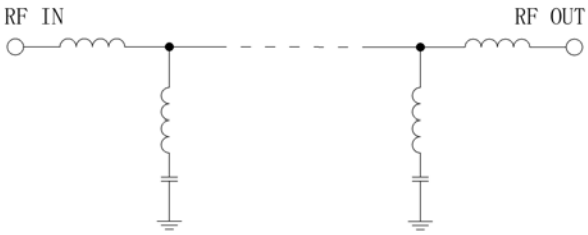
推荐装配图



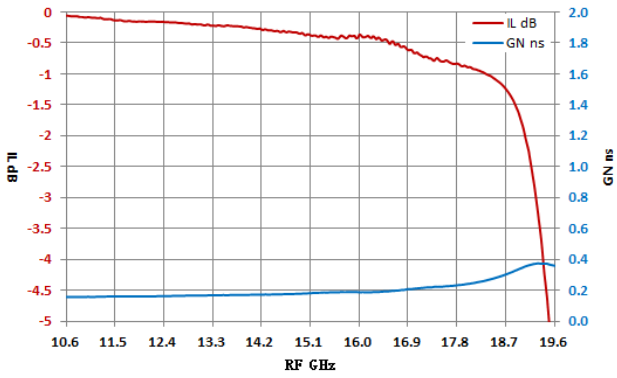
注意事项

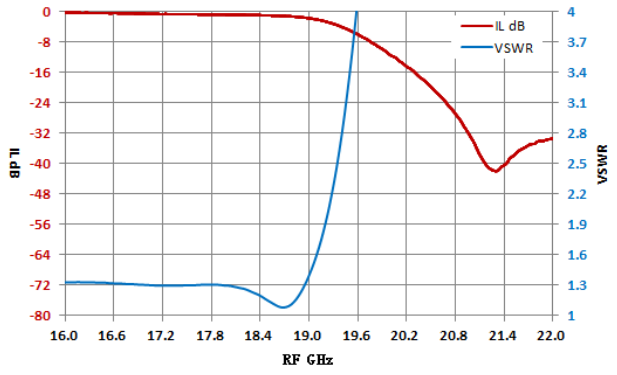
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

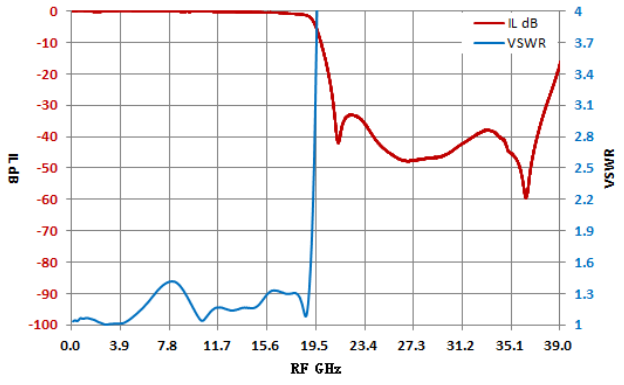
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

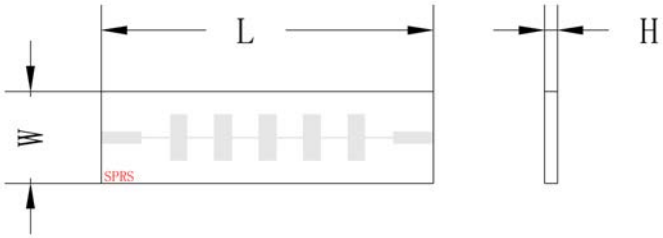
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.3	GHz
工作带宽	DC-18.6	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@23.0-36.0GHz	dBc

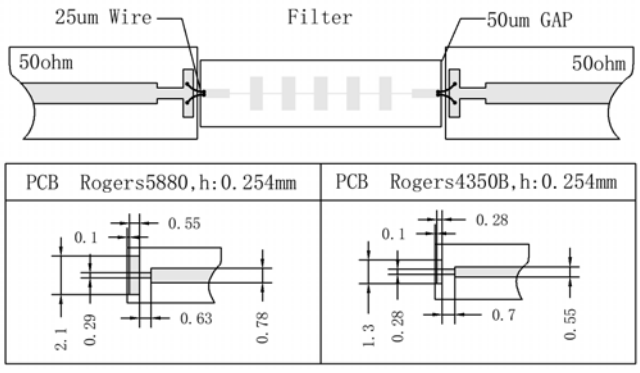
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：3.0，W：1.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

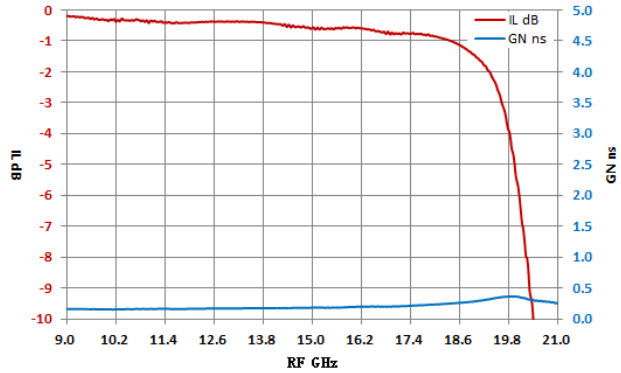
参考实物图

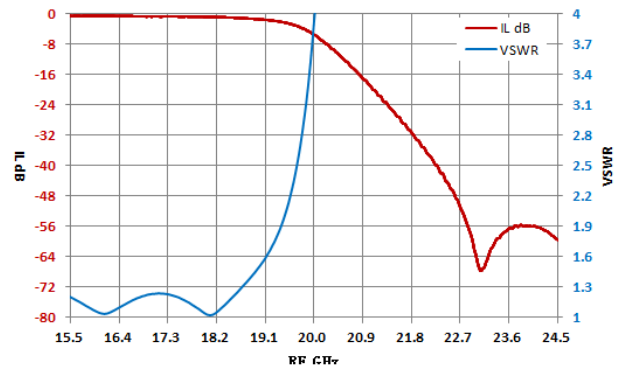


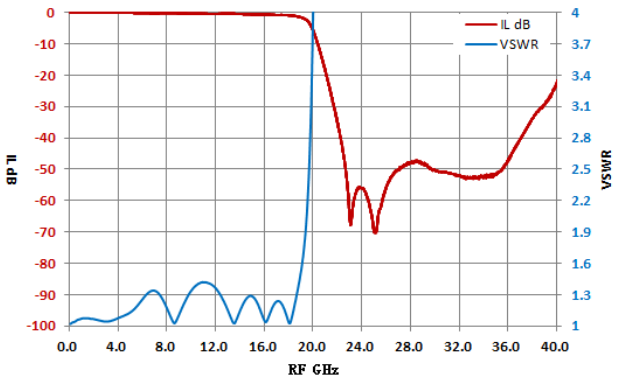
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

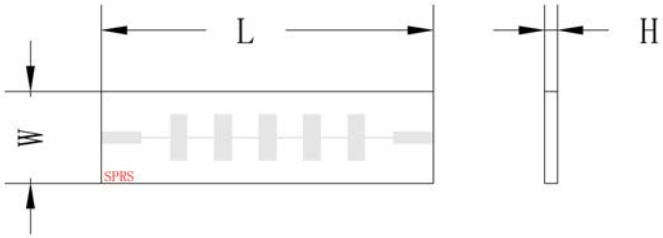
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.5	GHz
工作带宽	DC-19.0	GHz
通带损耗	1.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@22.7-32.0GHz	dBc

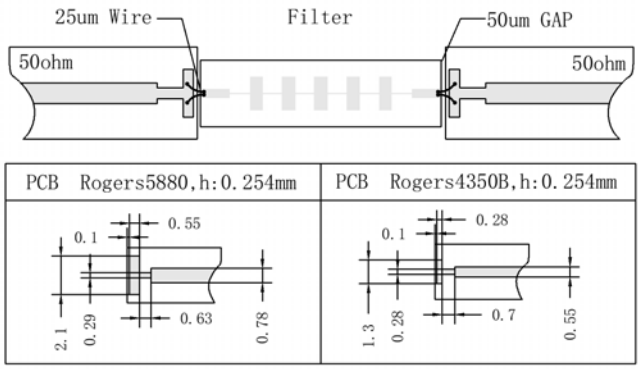
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：3.0，W：1.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

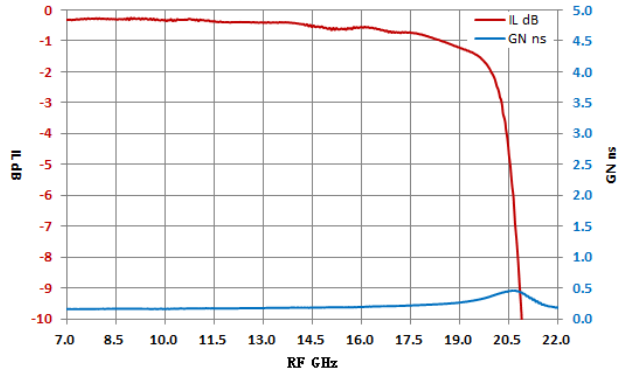
参考实物图

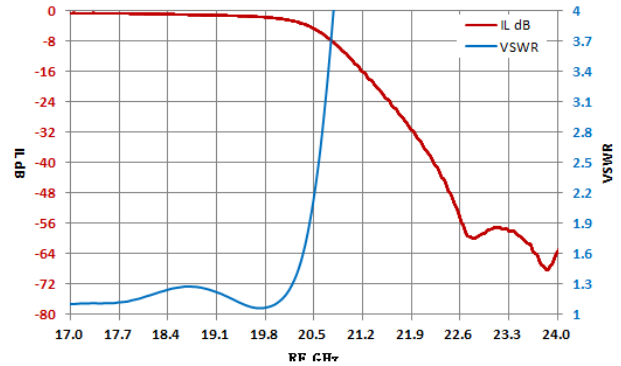


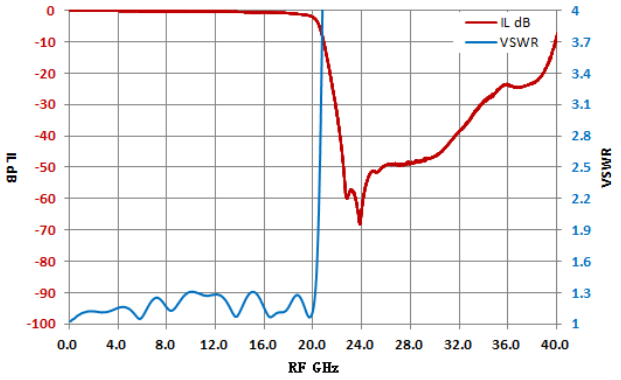
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



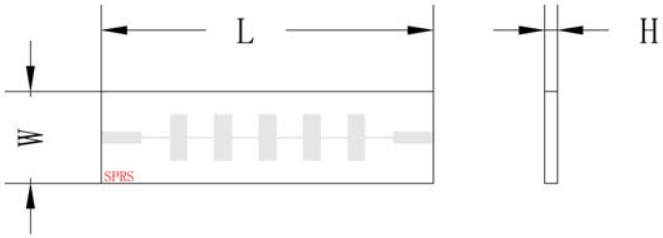
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.8	GHz
工作带宽	DC-19.6	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.5	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	30@23.0-36.0GHz	dBc

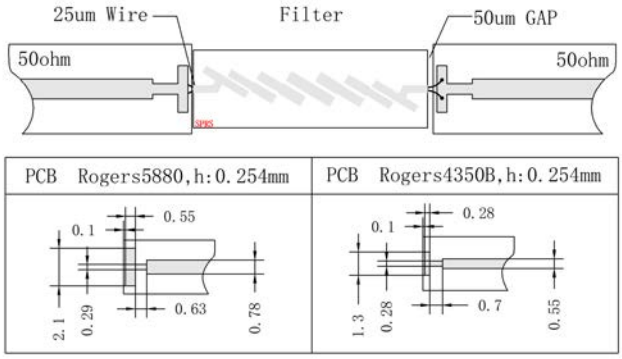
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：4.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



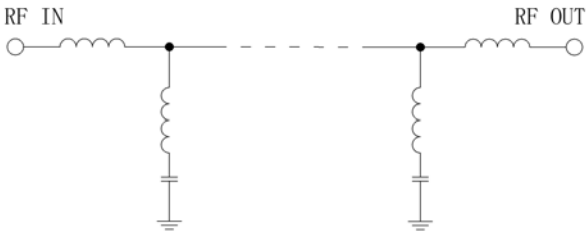
推荐装配图



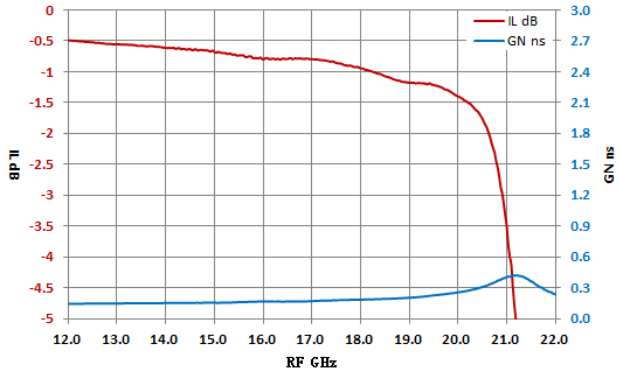
注意事项

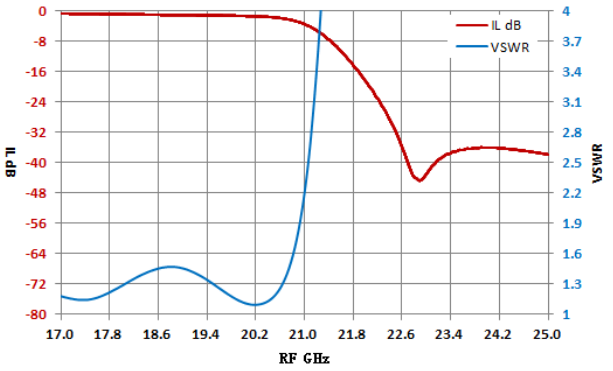
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

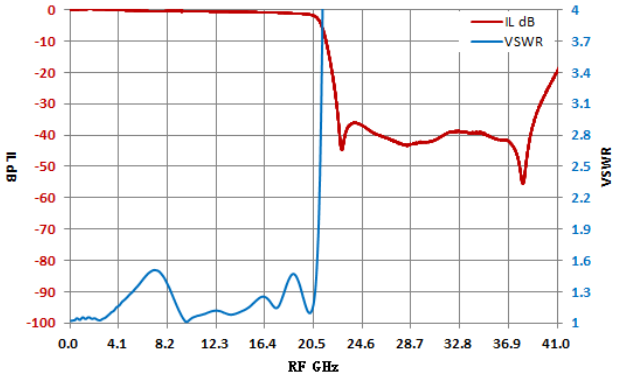
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



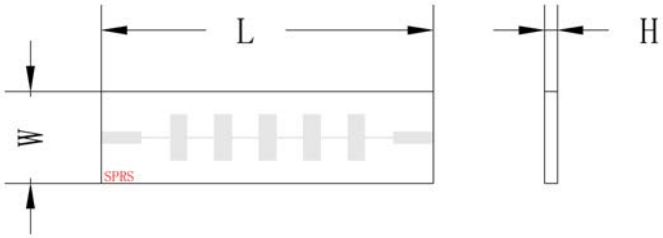
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	10.0	GHz
工作带宽	DC-20.0	GHz
通带损耗	2.5	dB
带内波动	2.5	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@22.8-34.0GHz	dBc

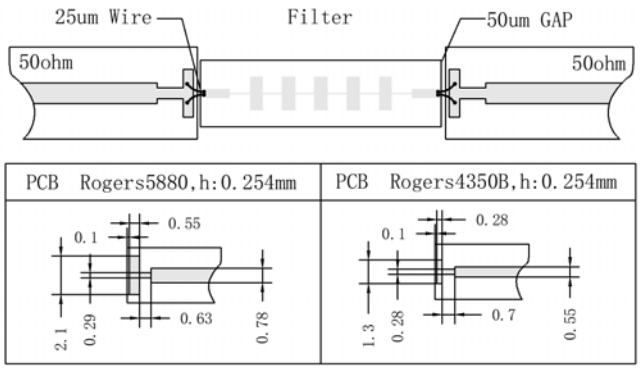
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：2.5，h：0.26

外形图：端口居中



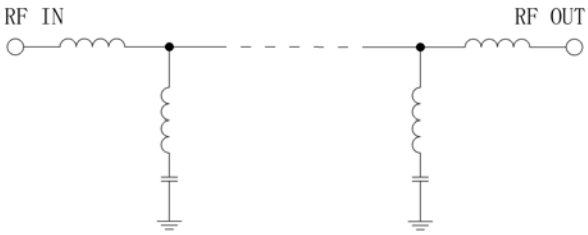
推荐装配图



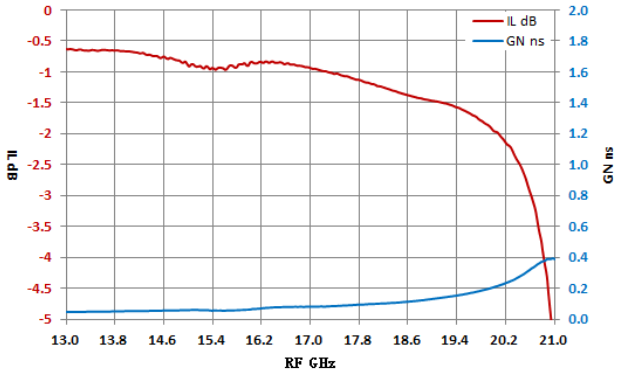
注意事项

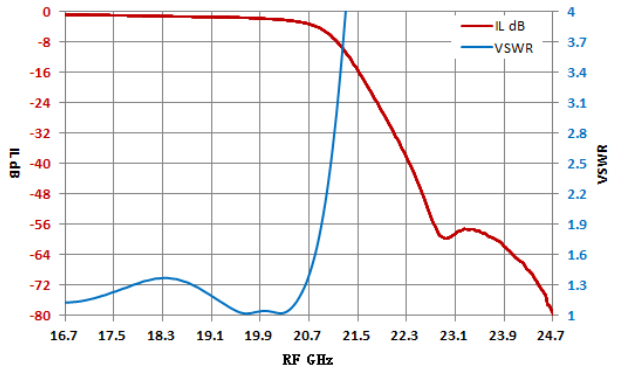
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

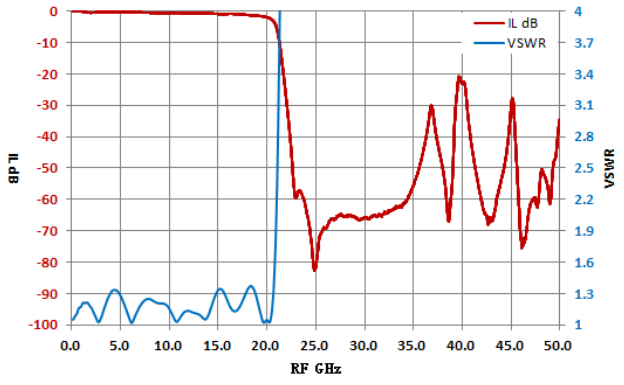
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

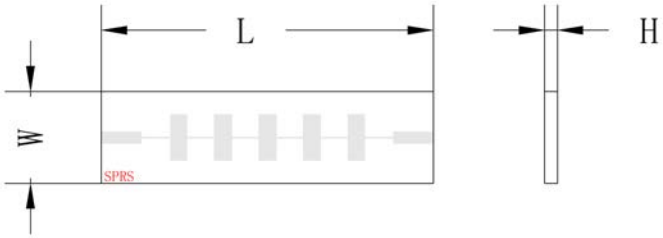
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	10.2	GHz
工作带宽	DC-20.4	GHz
通带损耗	1.5	
	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@24.1-33.0GHz	dBc

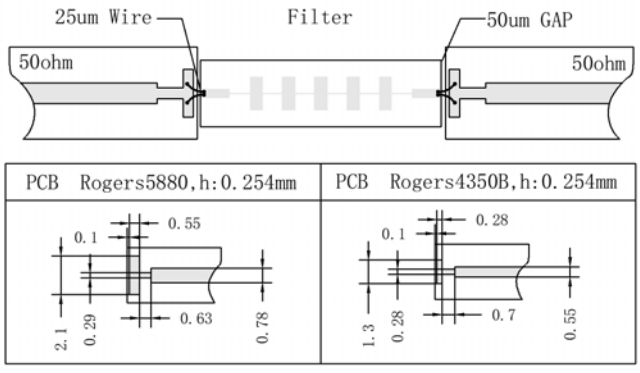
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：3.0，W：1.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

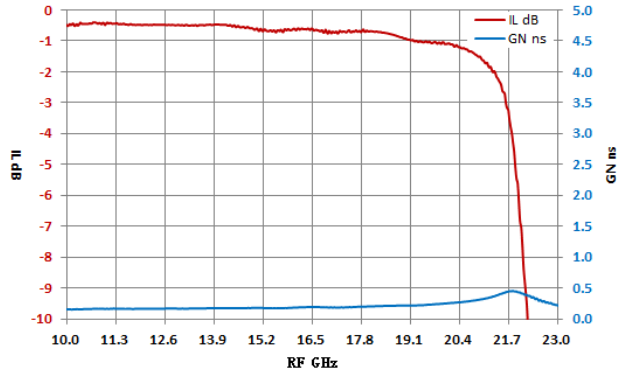
参考实物图

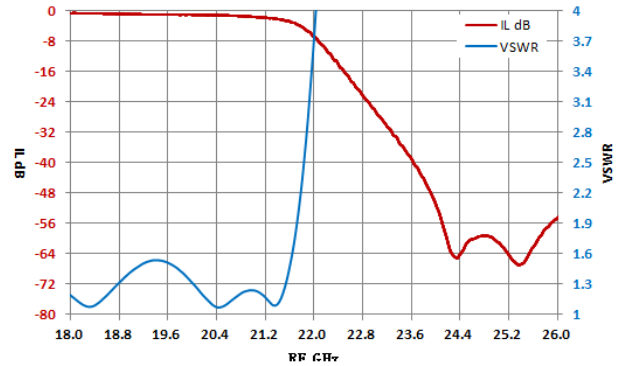


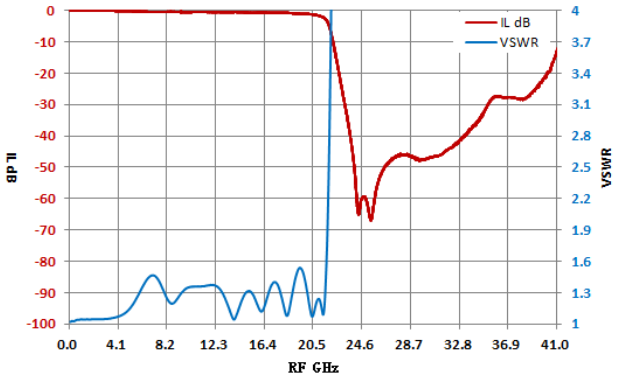
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



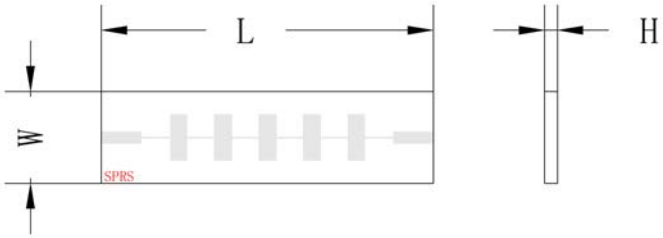
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	10.25	GHz
工作带宽	DC-20.5	GHz
通带损耗	2.0	dB
带内波动	2.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	30@25.5-42.0GHz	dBc

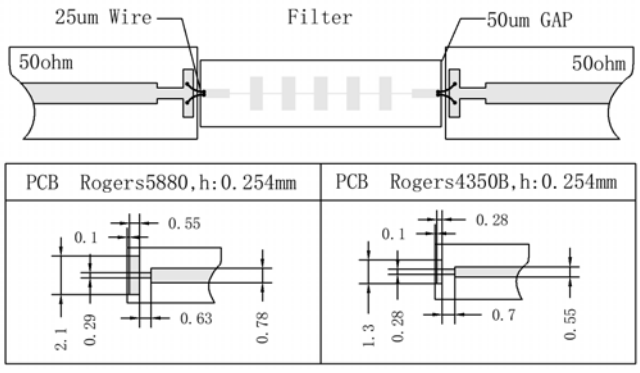
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：4.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



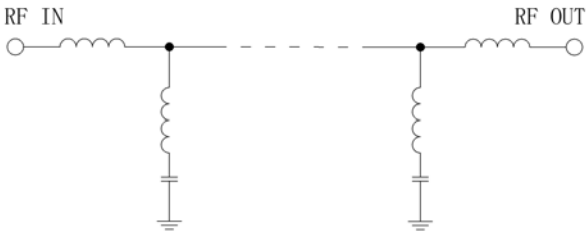
推荐装配图



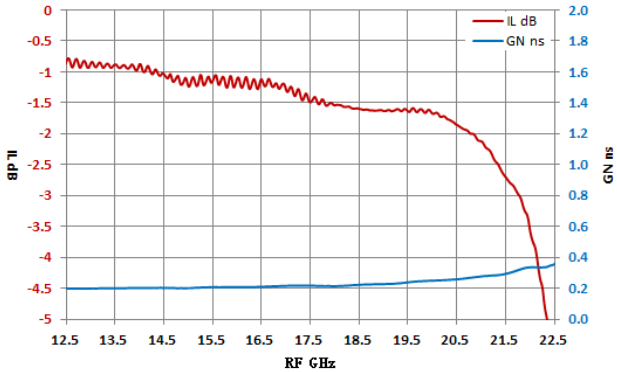
注意事项

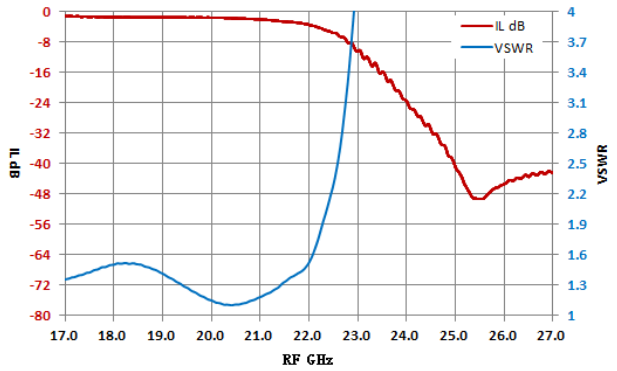
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

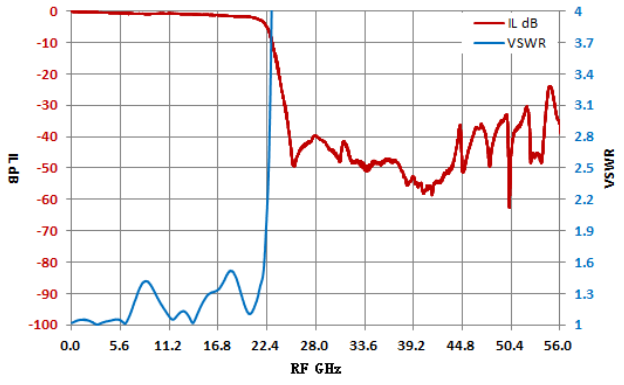
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



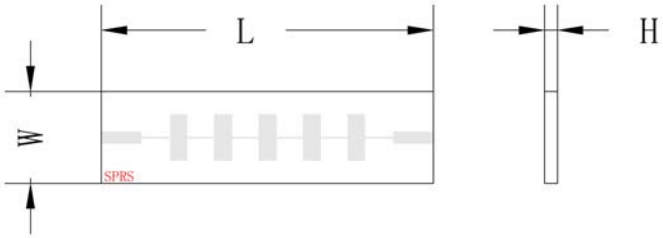
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	10.25	GHz
工作带宽	DC-20.5	GHz
通带损耗	2.0	dB
带内波动	2.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	30@27.0-43.0GHz	dBc

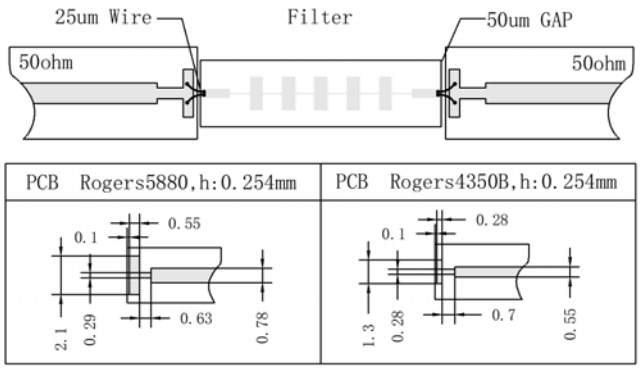
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：3.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



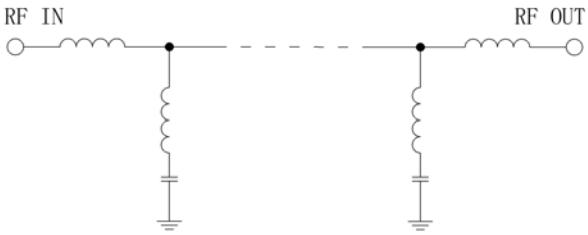
推荐装配图



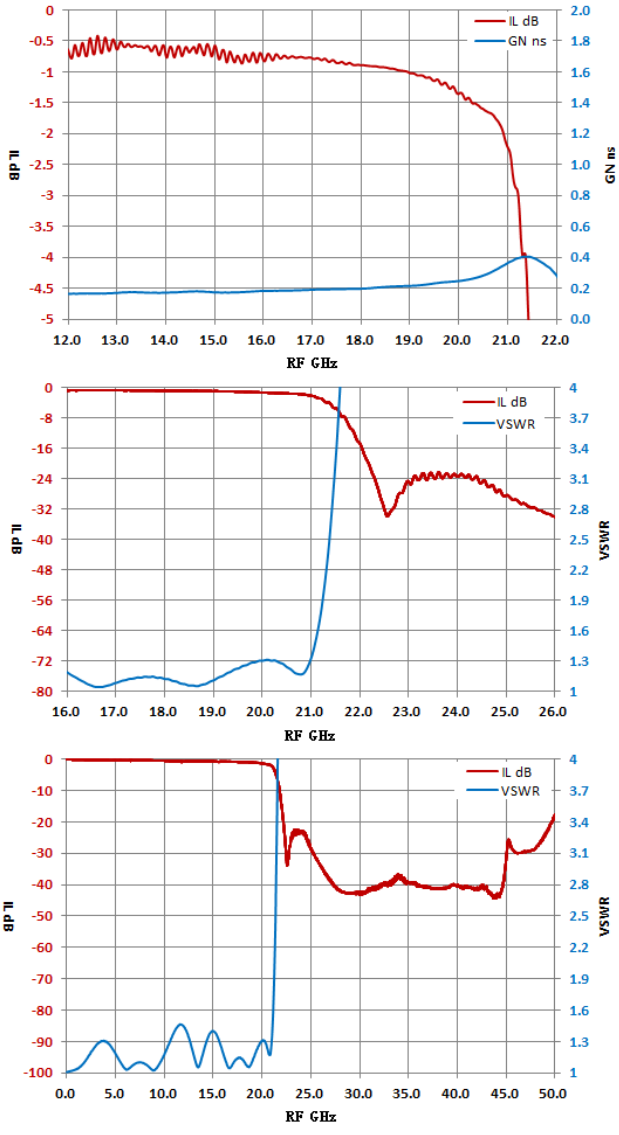
注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图



典型曲线



产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

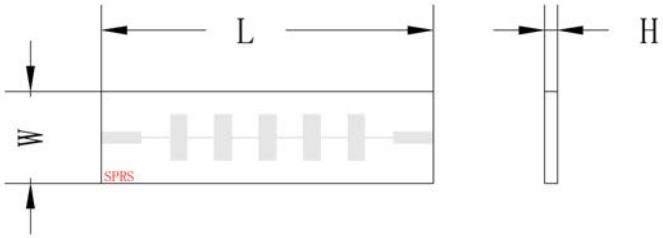
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	9.1	GHz
工作带宽	8.6-9.6	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@25.6-35.5GHz	dBc

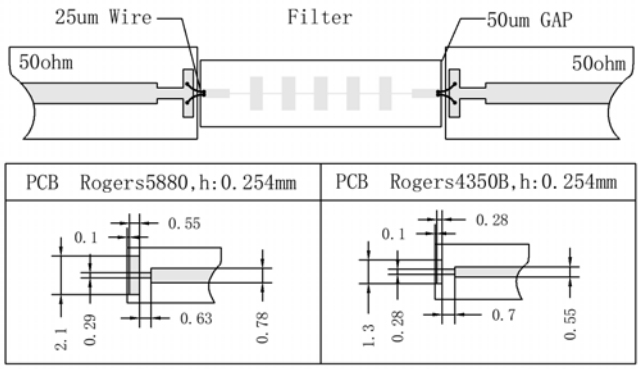
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：3.0，W：1.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

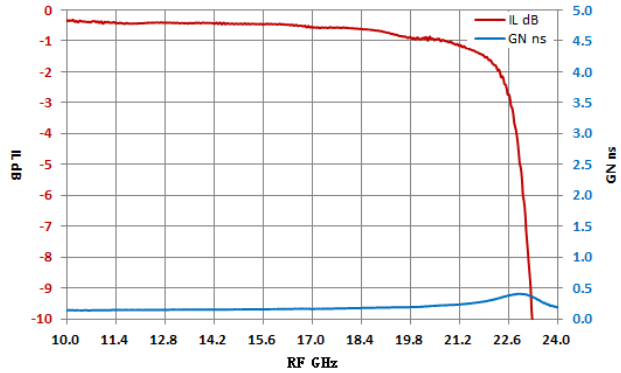
参考实物图

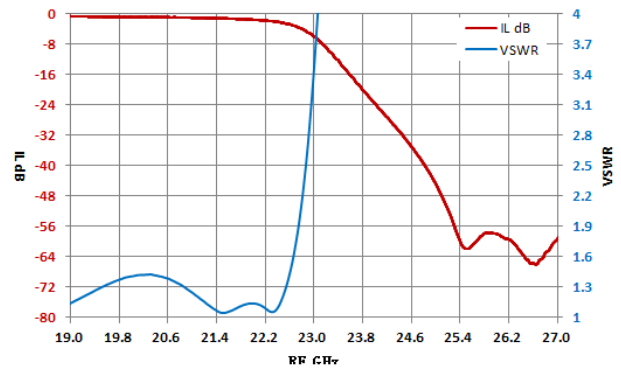


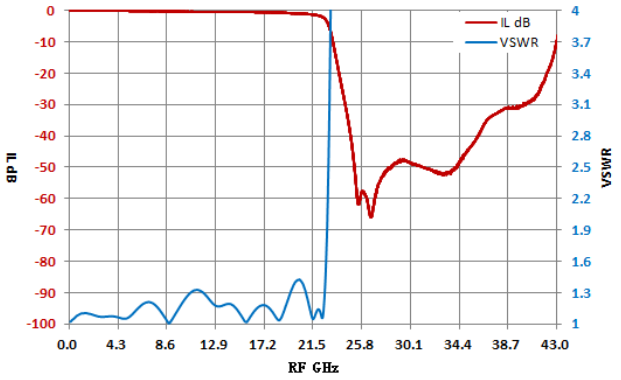
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



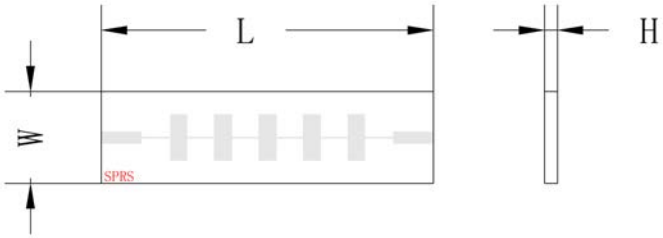
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	11.25	GHz
工作带宽	DC-22.5	GHz
通带损耗	2.0	dB
带内波动	2.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	30@29.0-46.0GHz	dBc

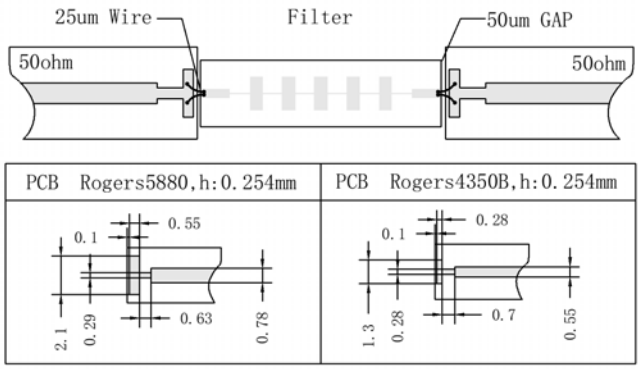
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：3.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



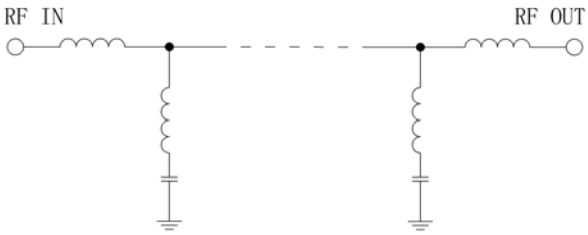
推荐装配图



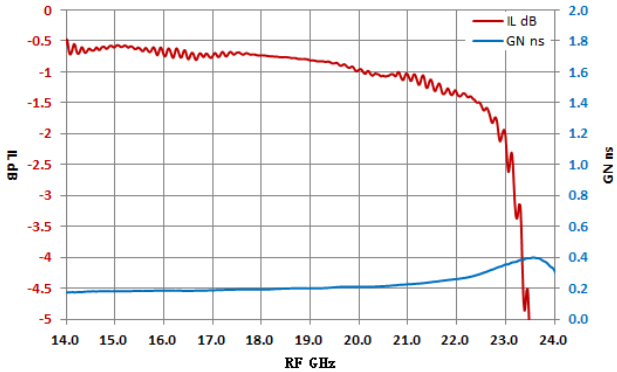
注意事项

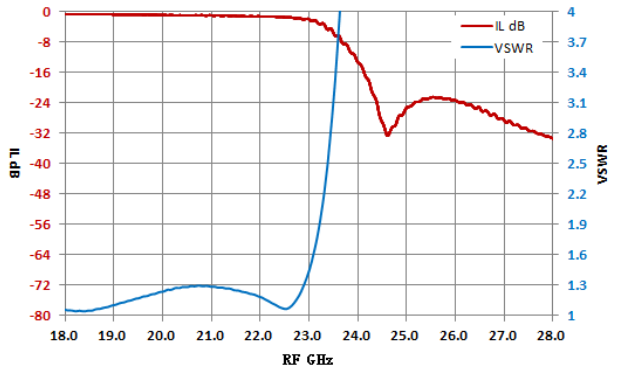
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

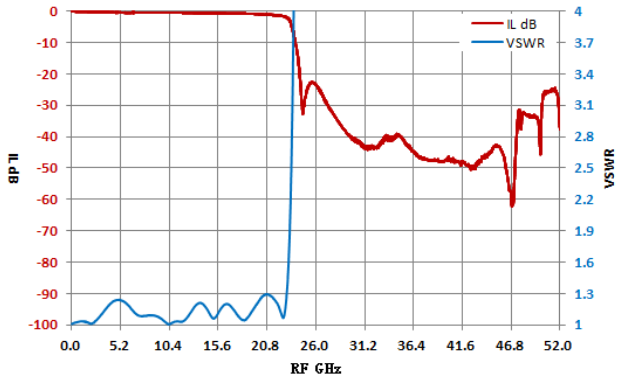
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

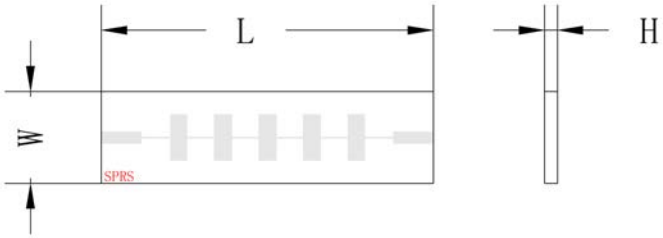
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	11.4	GHz
工作带宽	DC-22.8	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@27.0-37.4GHz	dBc

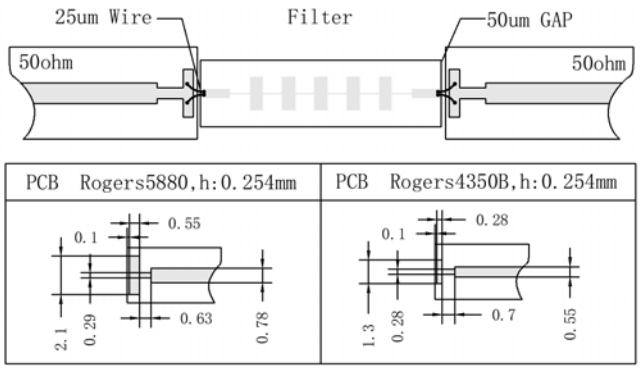
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：3.0，W：1.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

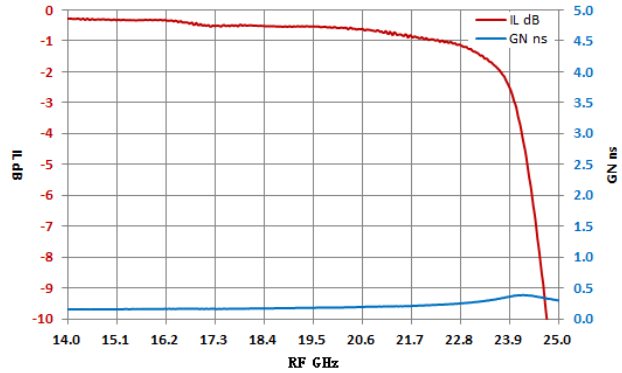
参考实物图

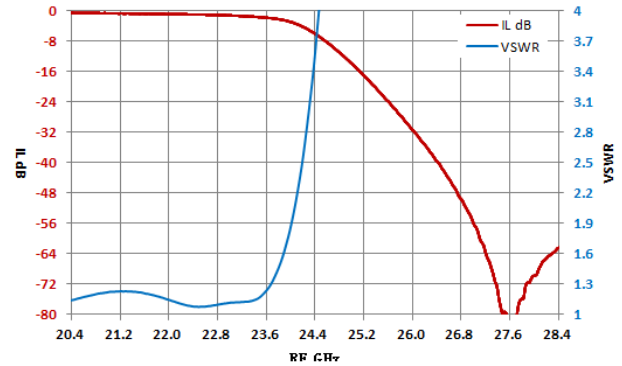


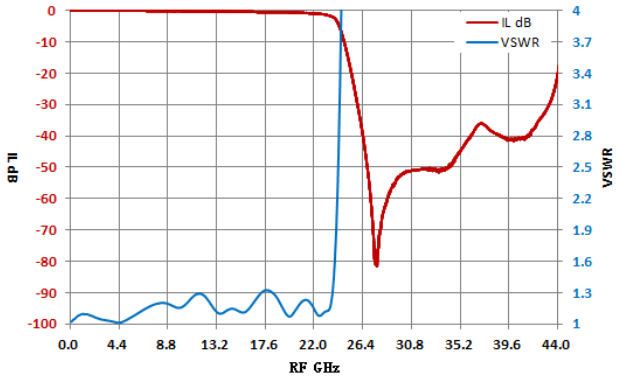
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



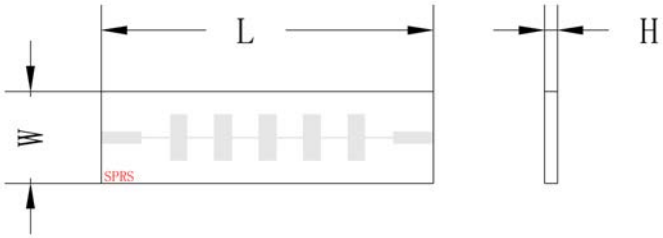
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	11.5	GHz
工作带宽	DC-23.0	GHz
通带损耗	3.0	dB
带内波动	3.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	1.0	ns
带外抑制	40@26.7-38.0GHz	dBc

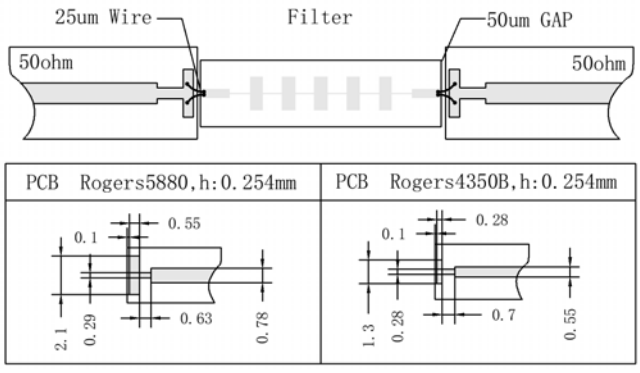
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



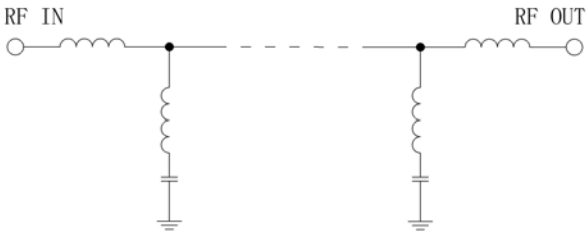
推荐装配图



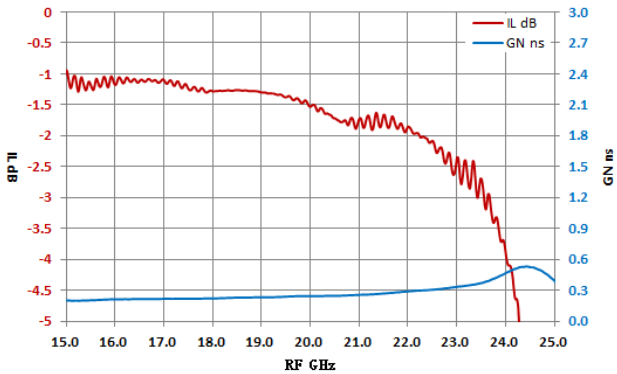
注意事项

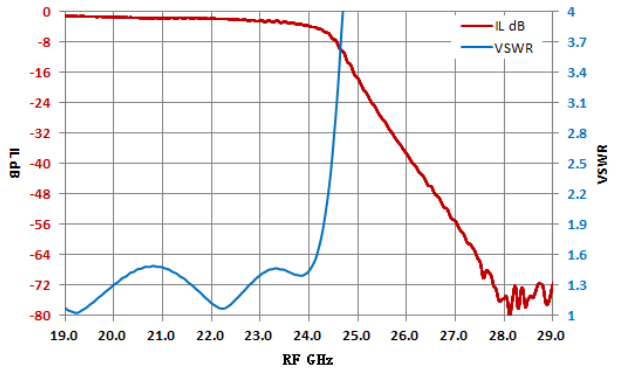
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

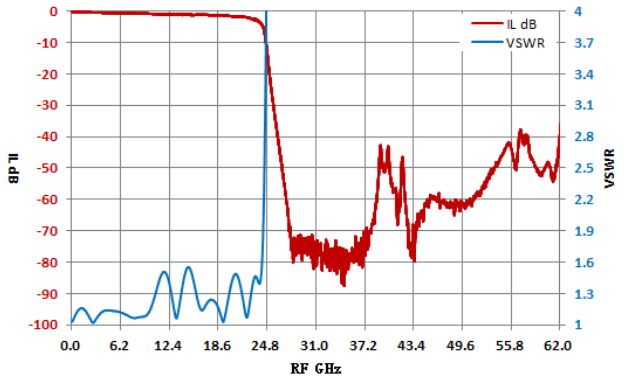
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

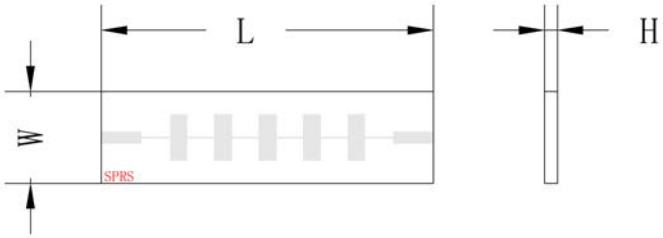
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	11.8	GHz
工作带宽	DC-23.6	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@28.5-40.5GHz	dBc

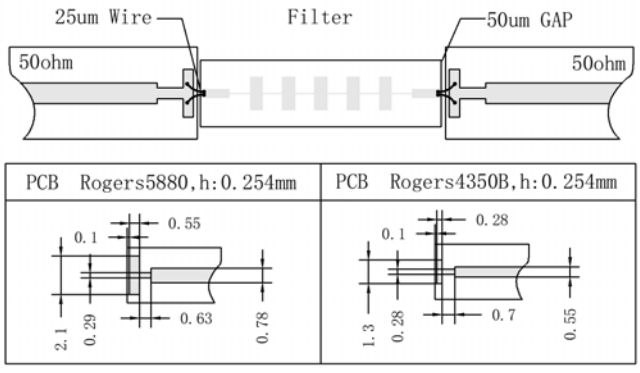
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：3.0，W：1.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

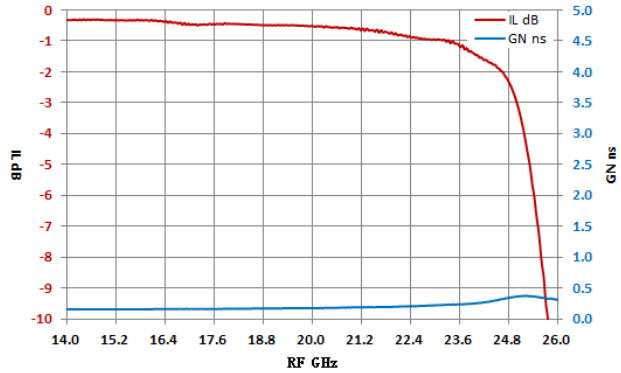
参考实物图

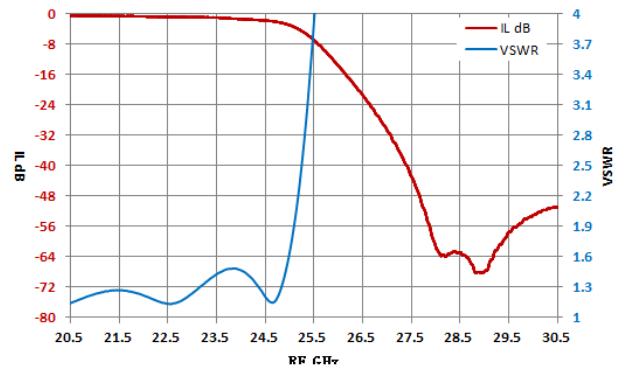


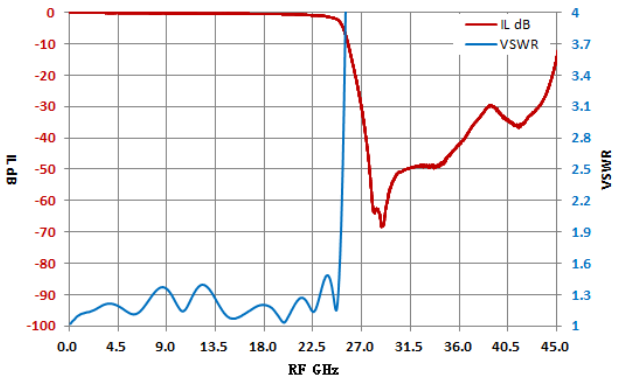
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



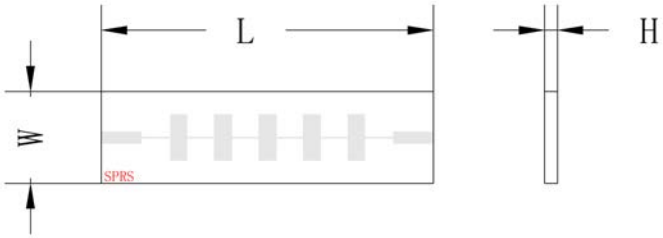
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	11.9	GHz
工作带宽	DC-23.8	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.5	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	30@28.2-42.0GHz	dBc

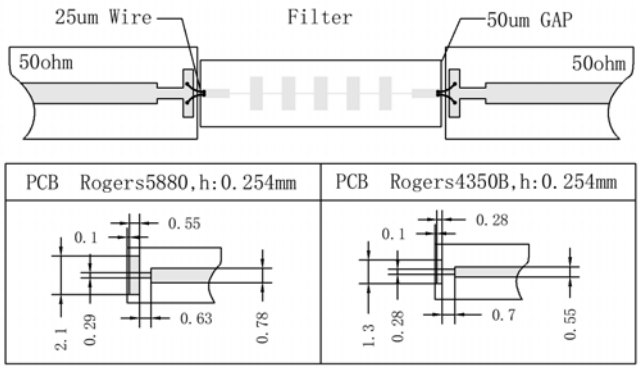
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：4.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



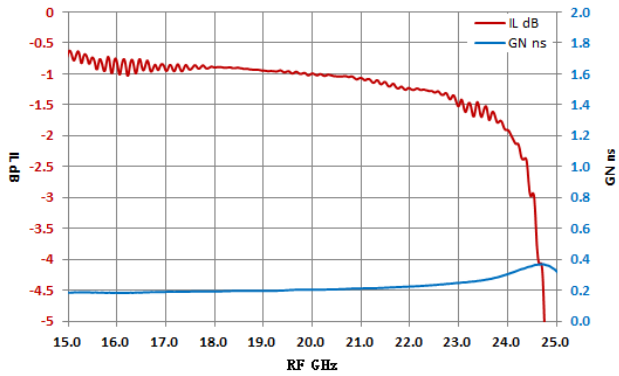
注意事项

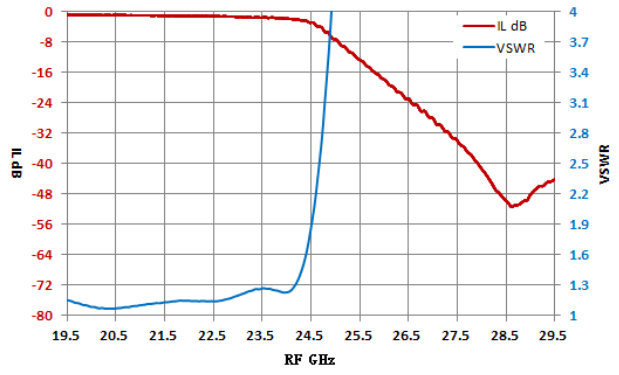
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

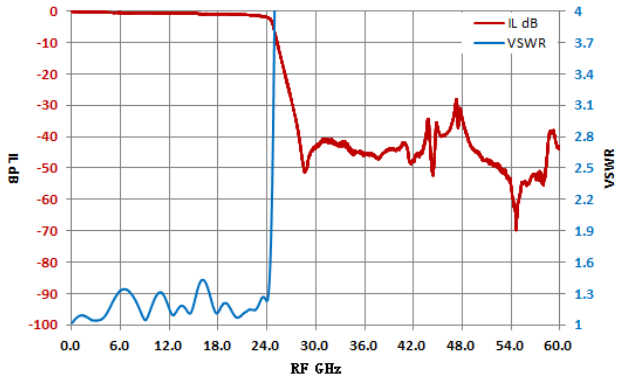
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

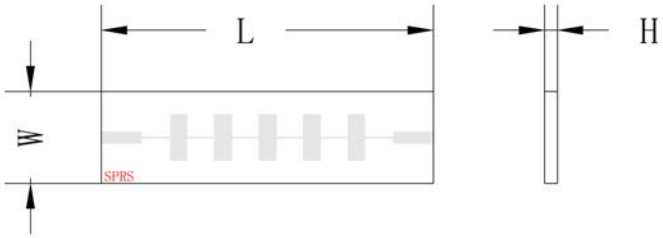
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	12.0	GHz
工作带宽	DC-24.0	GHz
通带损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@28.9-40.5GHz	dBc

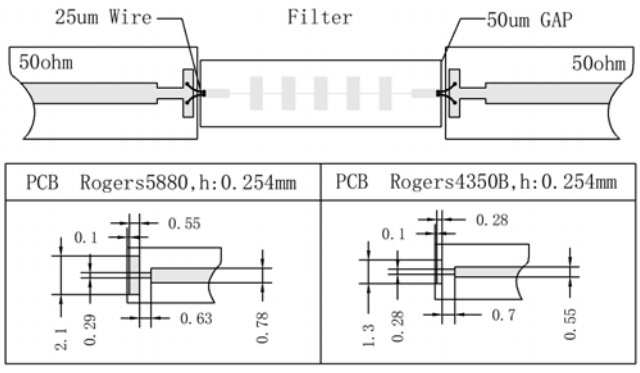
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：3.0，W：1.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

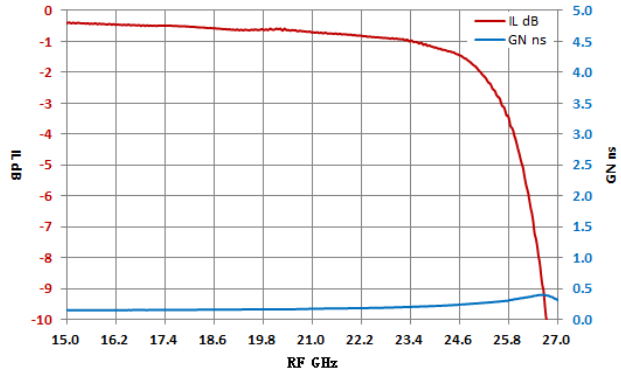
参考实物图

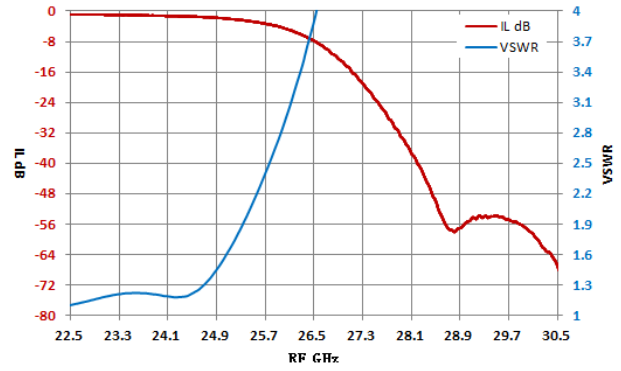


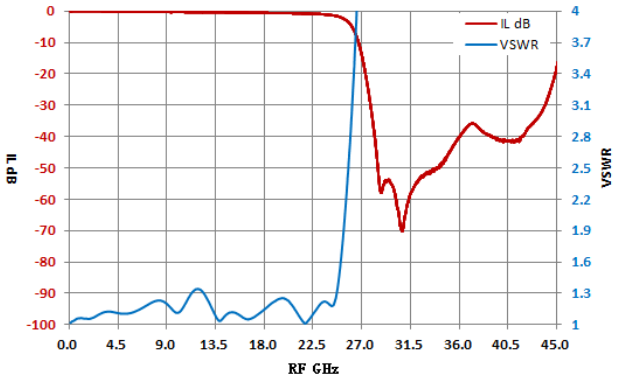
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



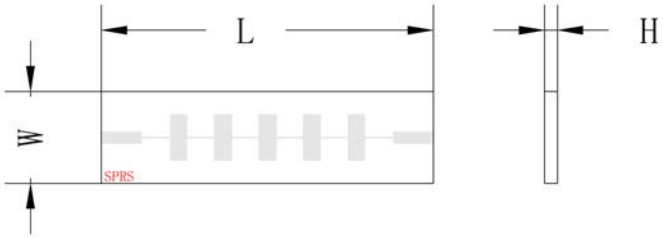
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	12.25	GHz
工作带宽	DC-24.5	GHz
通带损耗	2.0	dB
带内波动	2.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	20@26.9-48.0GHz	dBc

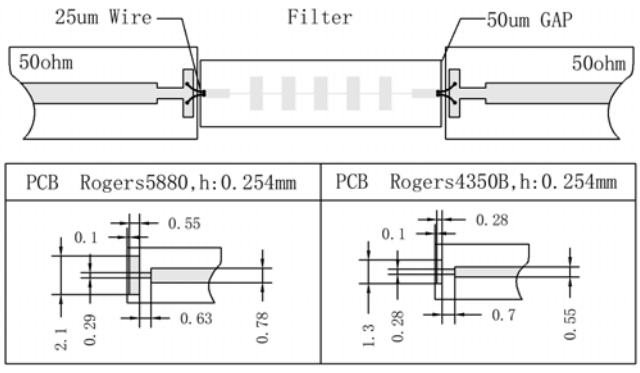
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：3.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



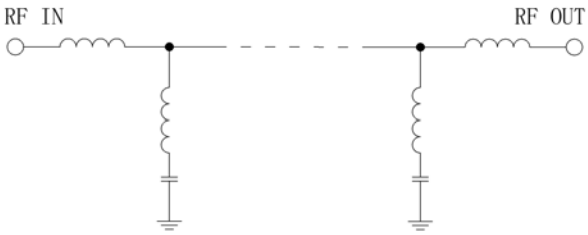
推荐装配图



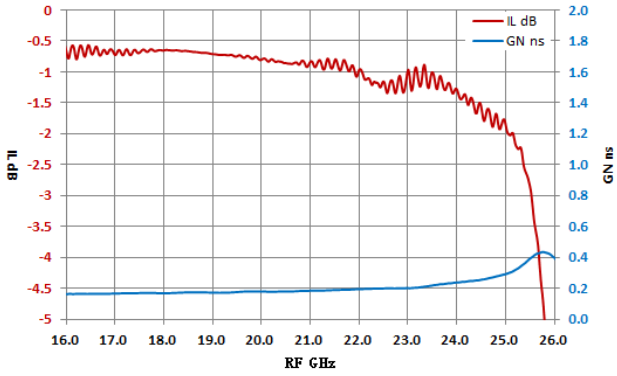
注意事项

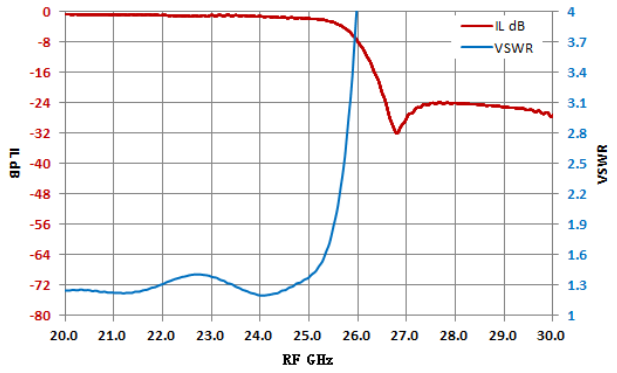
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

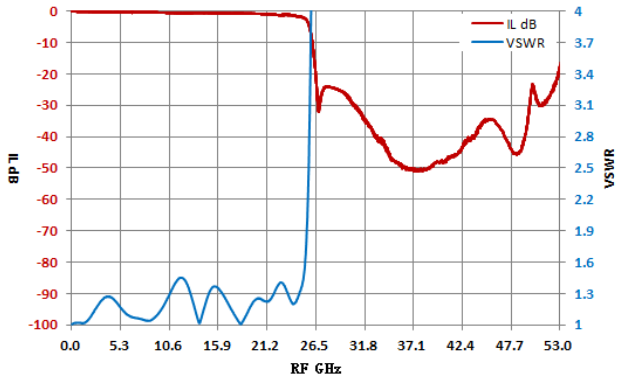
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



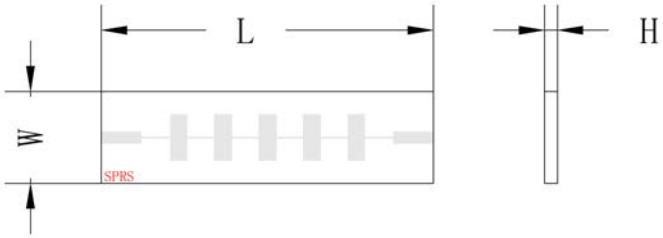
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	12.4	GHz
工作带宽	DC-24.8	GHz
通带损耗	2.0	dB
带内波动	2.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	30@30.5-60.0GHz	dBc

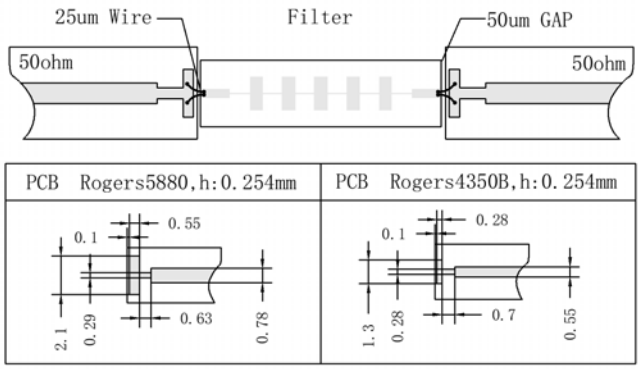
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：1.8，h：0.26

外形图：端口居中



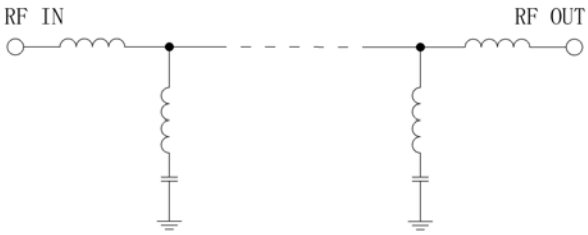
推荐装配图



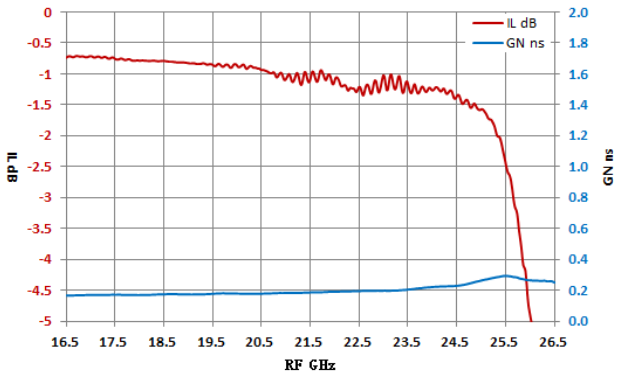
注意事项

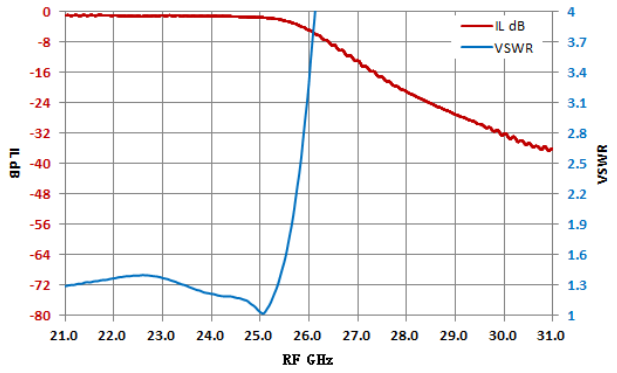
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

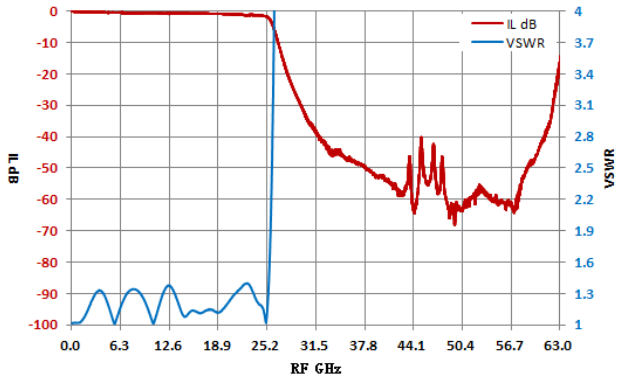
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



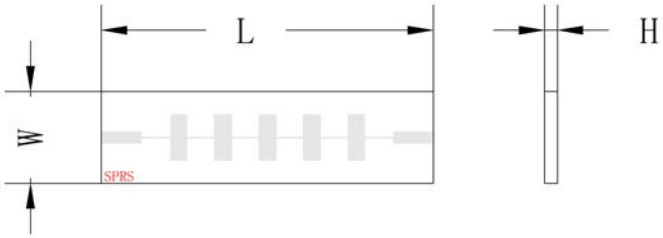
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	13.0	GHz
工作带宽	DC-26.0	GHz
通带损耗	2.0	dB
带内波动	2.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	30@30.0-42.0GHz	dBc

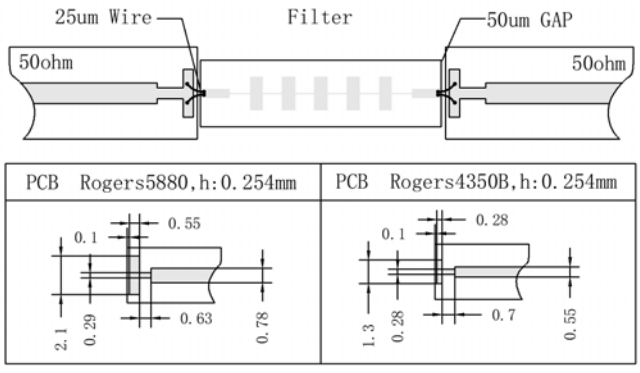
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：4.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



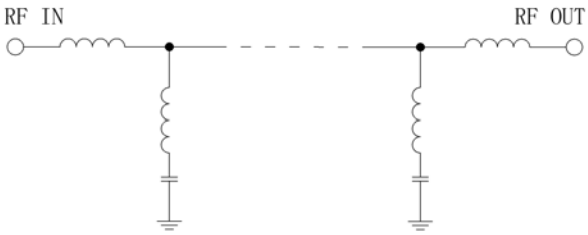
推荐装配图



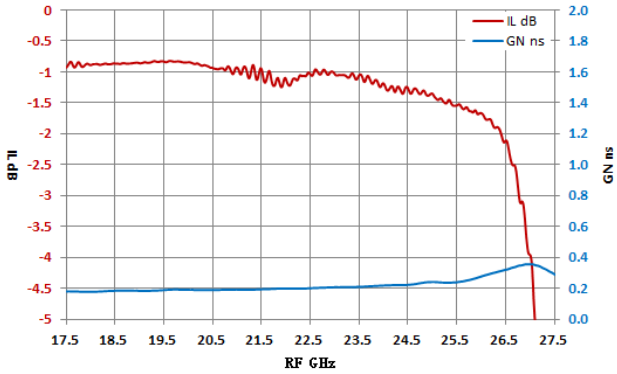
注意事项

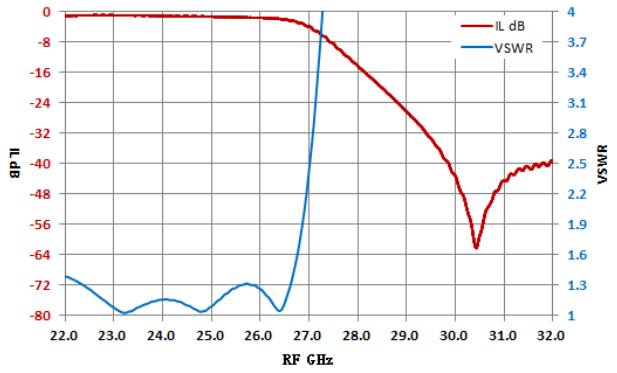
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

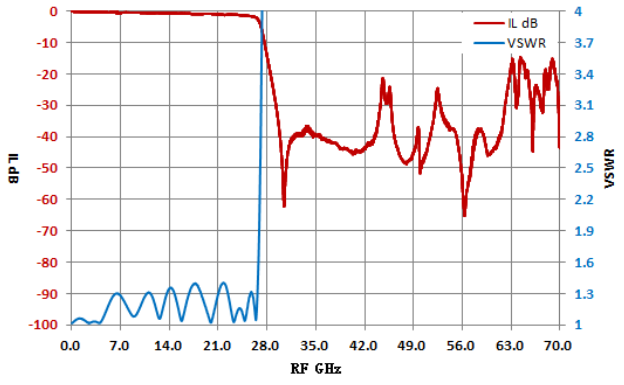
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



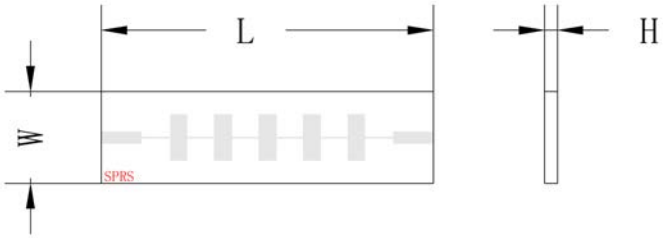
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	13.1	GHz
工作带宽	DC-26.2	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.5	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	35@38.0-56.0GHz	dBc

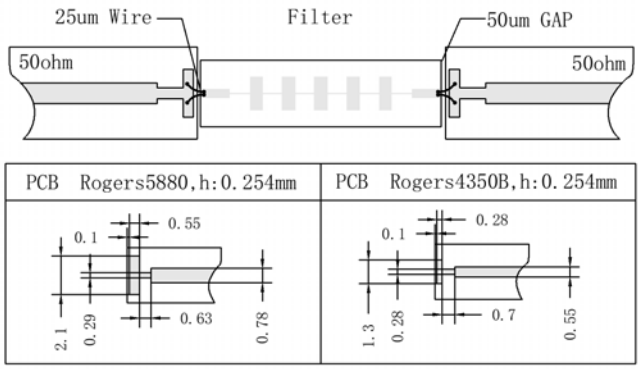
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：5.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



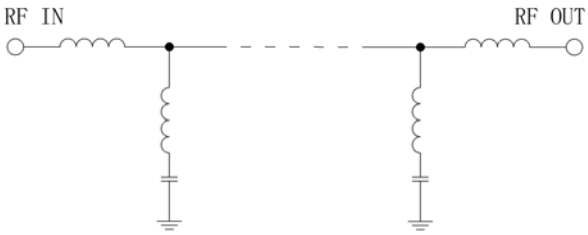
推荐装配图



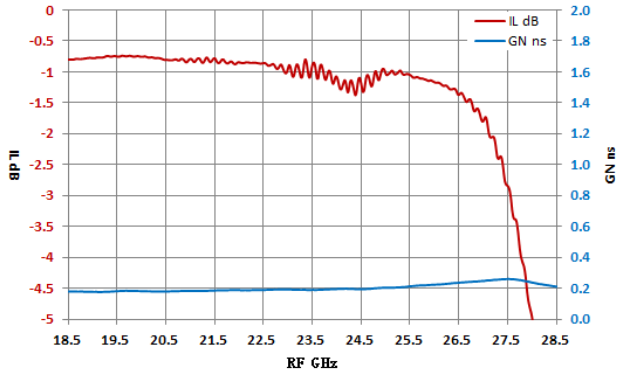
注意事项

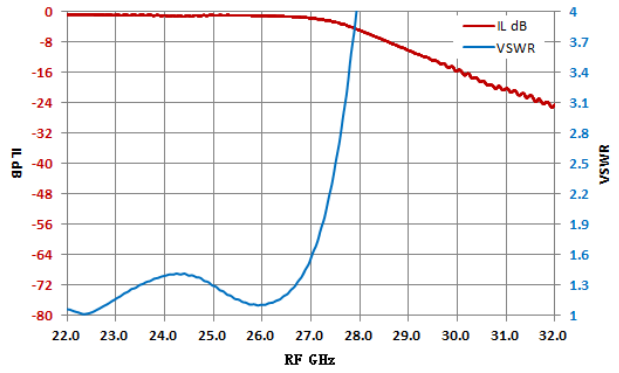
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

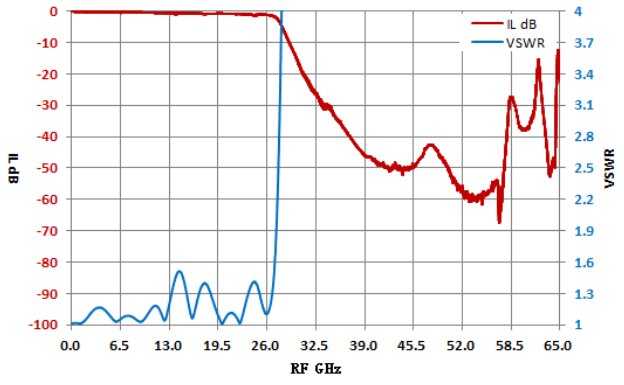
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

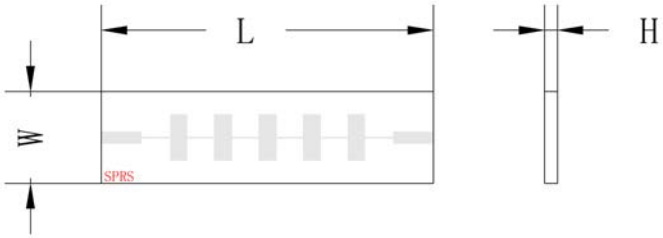
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	13.1	GHz
工作带宽	DC-26.2	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@30.9-42.5GHz	dBc

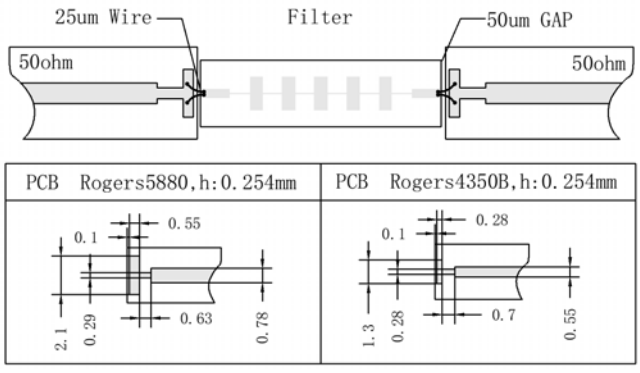
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：3.0，W：1.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

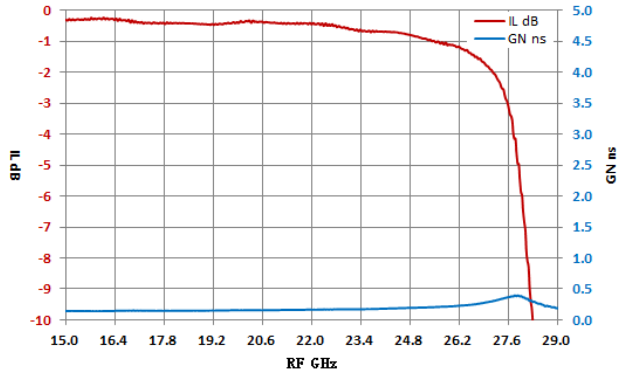
参考实物图

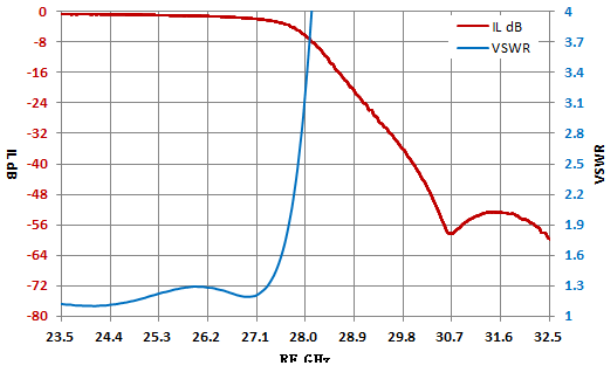


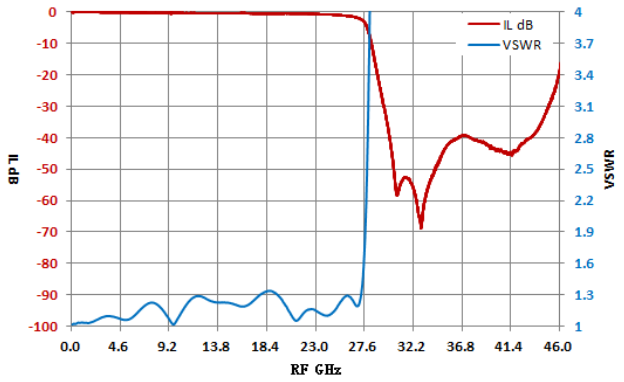
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



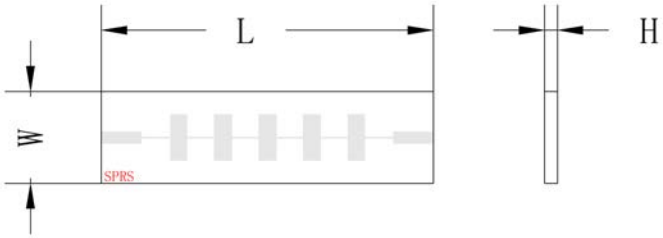
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	13.25	GHz
工作带宽	DC-26.5	GHz
通带损耗	2.0	dB
带内波动	2.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	25@34.0-52.0GHz	dBc

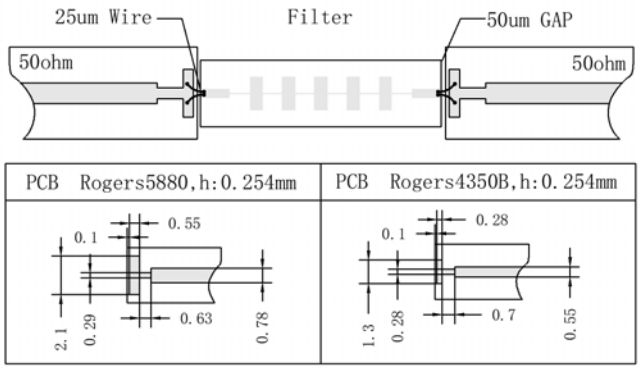
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：3.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



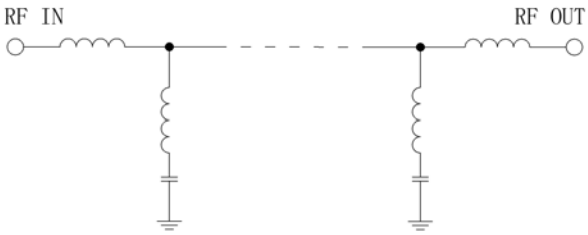
推荐装配图



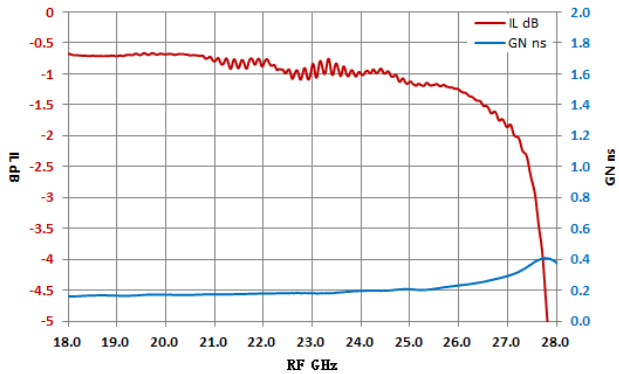
注意事项

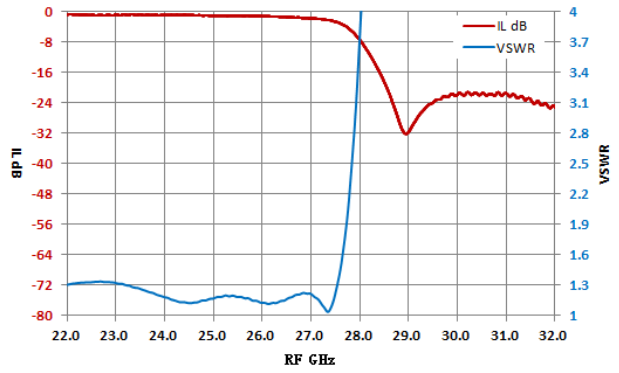
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

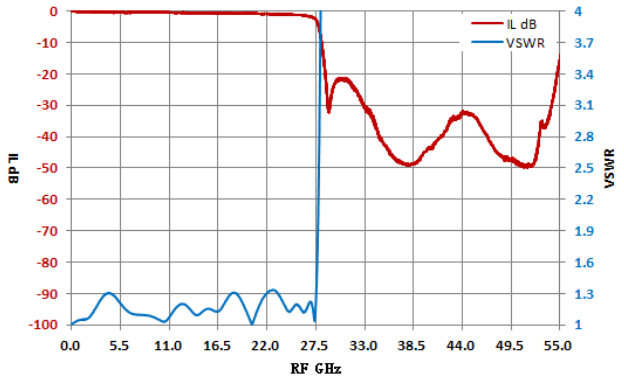
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

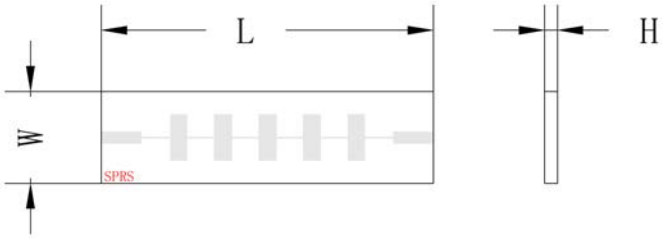
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	13.7	GHz
工作带宽	DC-27.4	GHz
通带损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@36.0-50.0GHz	dBc

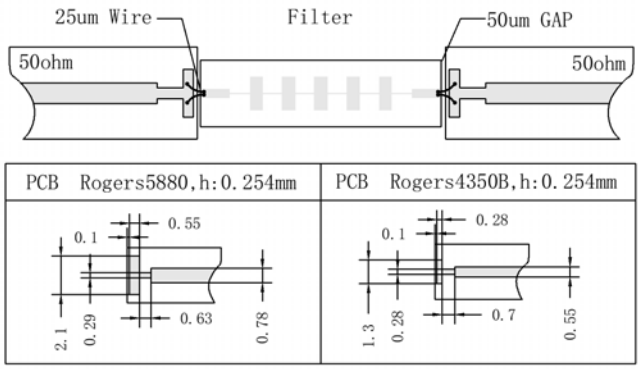
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：5.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

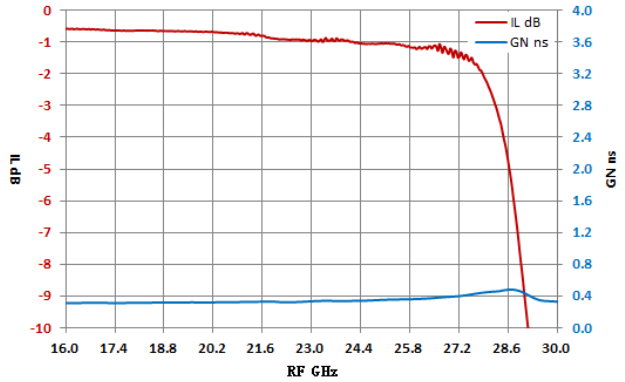
参考实物图

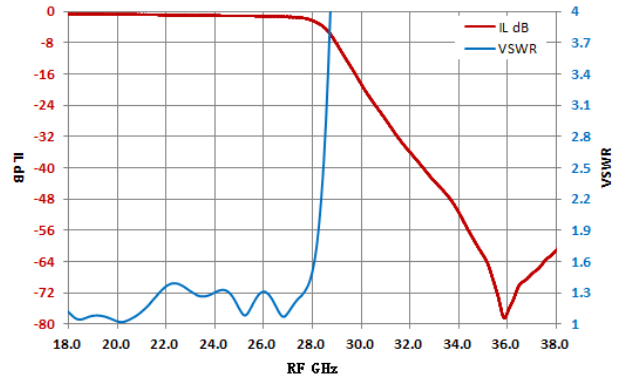


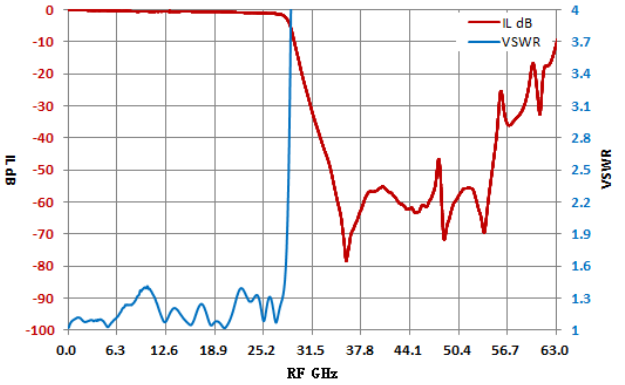
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

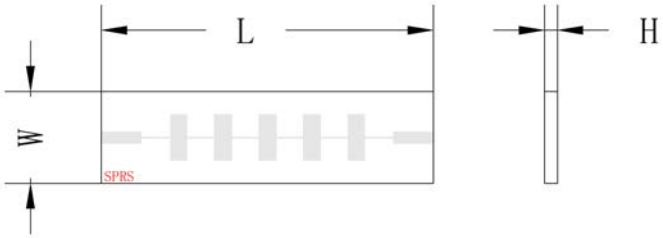
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	13.9	GHz
工作带宽	DC-27.8	GHz
通带损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@32.0-38.0GHz	dBc

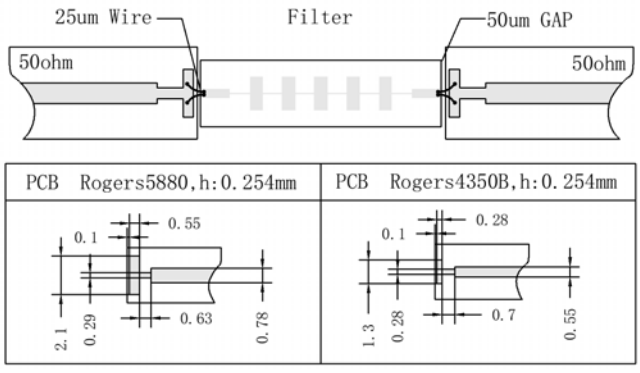
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：3.0，W：1.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

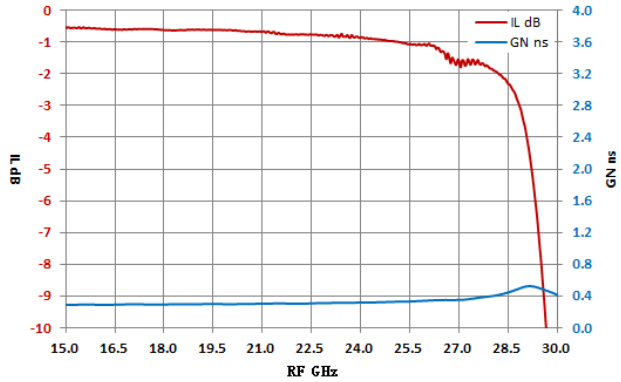
参考实物图

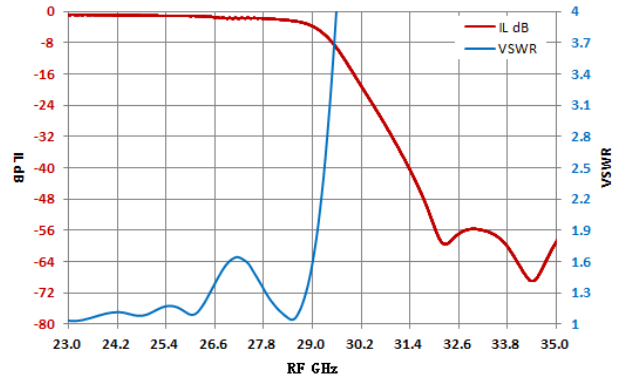


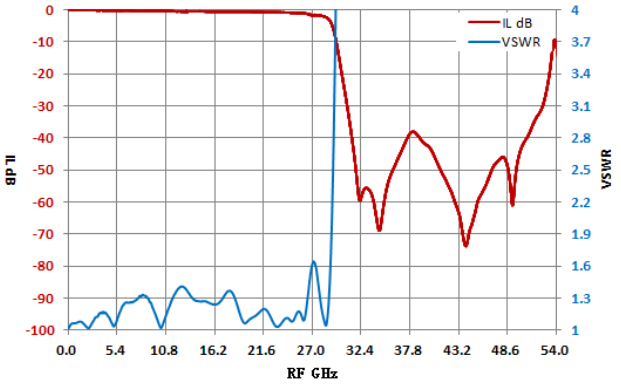
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



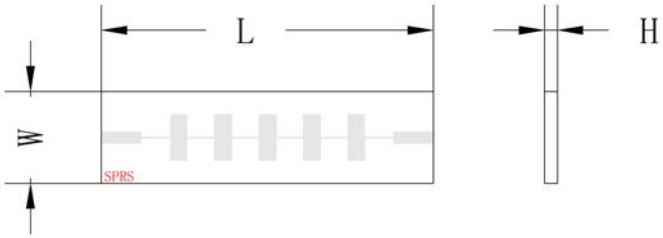
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	14.0	GHz
工作带宽	DC-28.0	GHz
通带损耗	2.0	dB
带内波动	2.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	35@32.5-43.0GHz	dBc

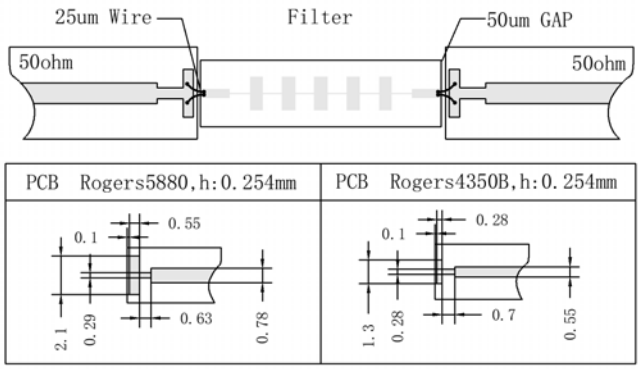
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：4.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



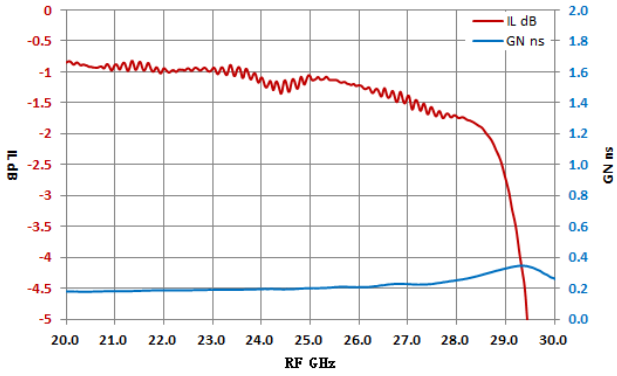
注意事项

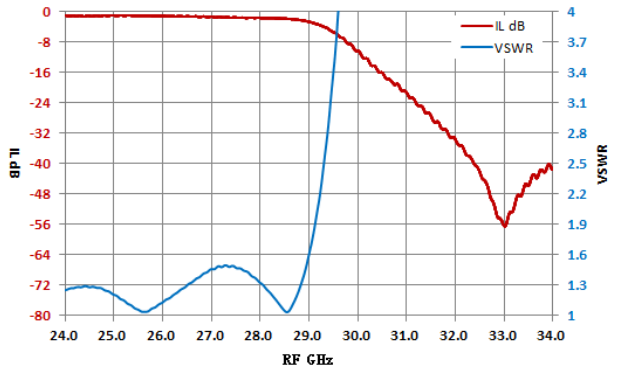
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

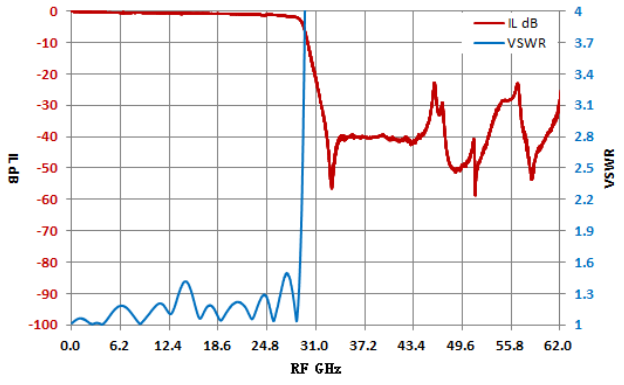
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



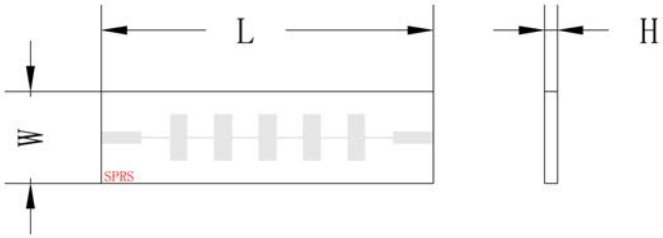
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	14.25	GHz
工作带宽	DC-28.5	GHz
通带损耗	2.0	dB
带内波动	2.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	20@30.8-54.0GHz	dBc

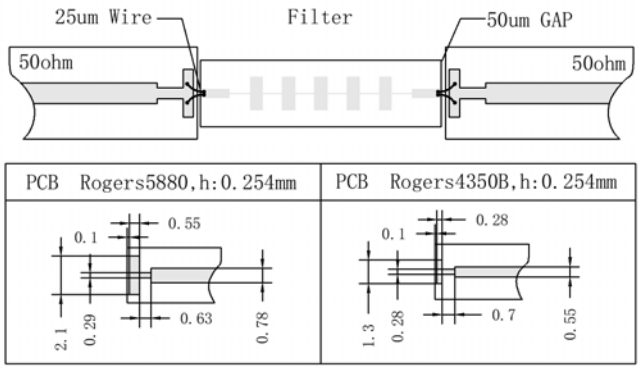
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：3.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



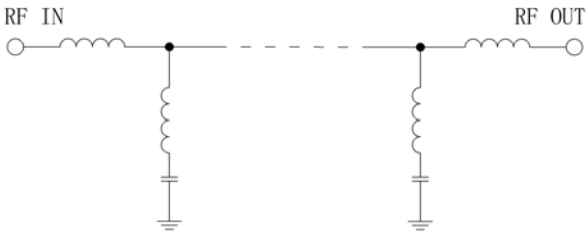
推荐装配图



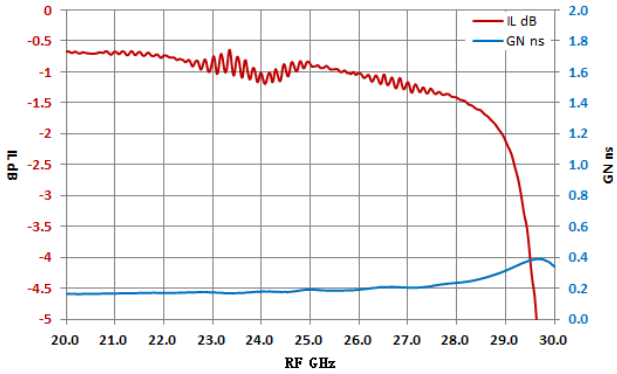
注意事项

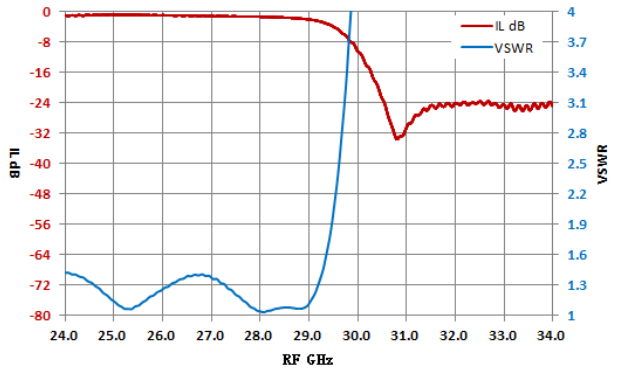
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

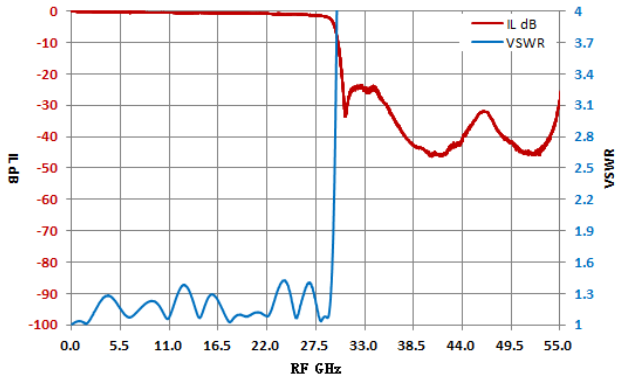
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

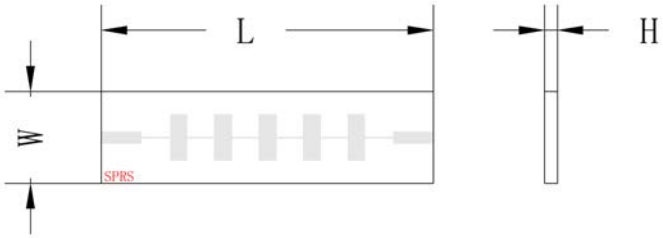
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	14.6	GHz
工作带宽	DC-29.2	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@34.2-47.0GHz	dBc

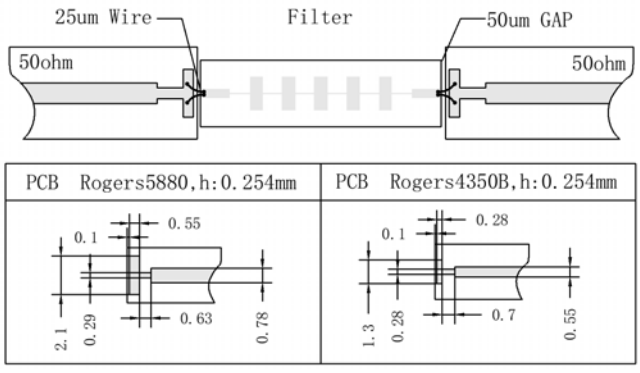
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：3.0，W：1.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

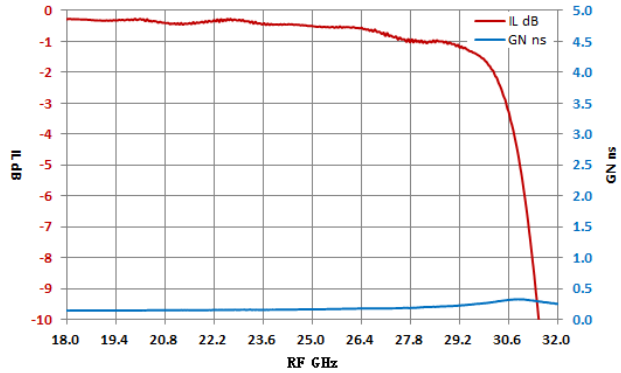
参考实物图

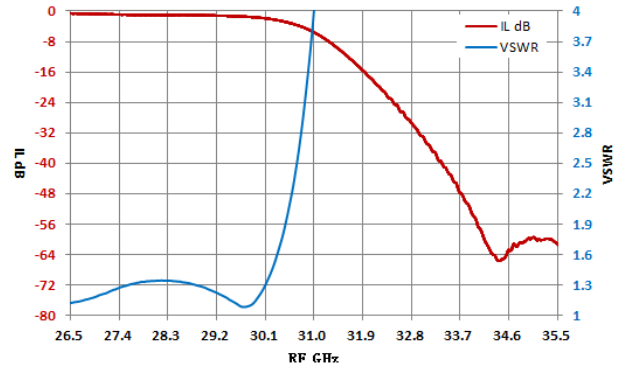


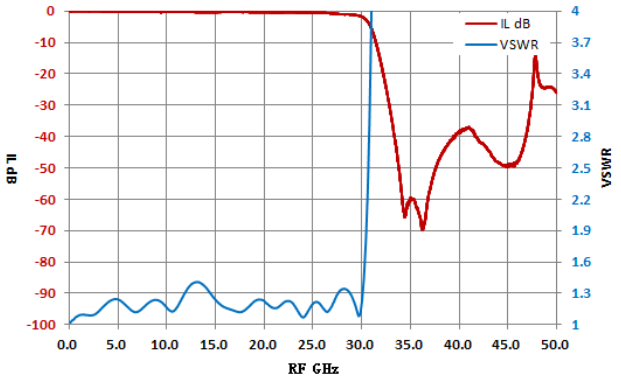
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



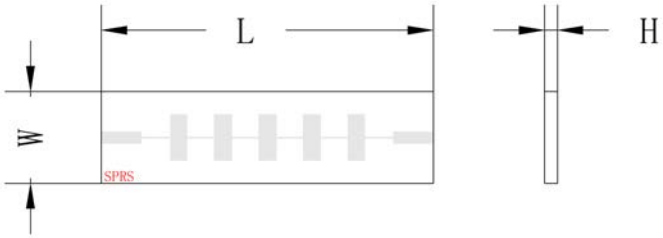
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	14.75	GHz
工作带宽	DC-29.5	GHz
通带损耗	2.0	dB
带内波动	2.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@36.5-51.0GHz	dBc

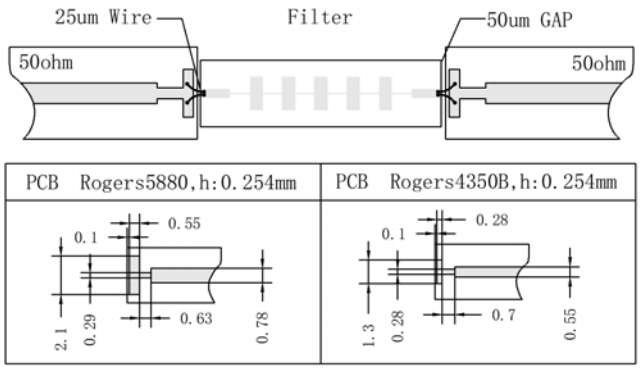
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：5.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



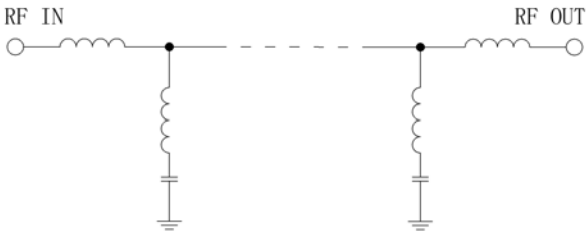
推荐装配图



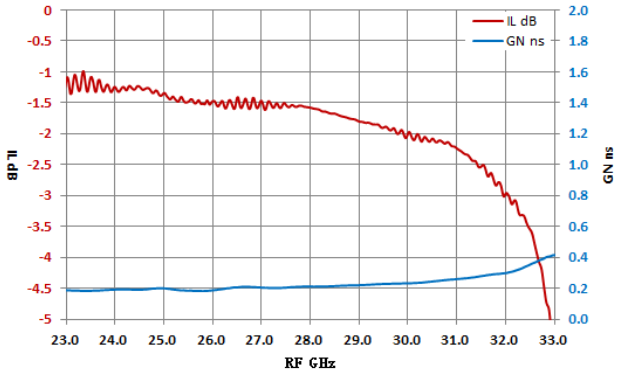
注意事项

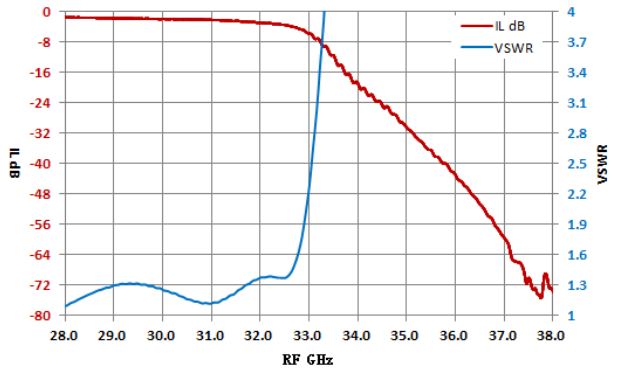
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

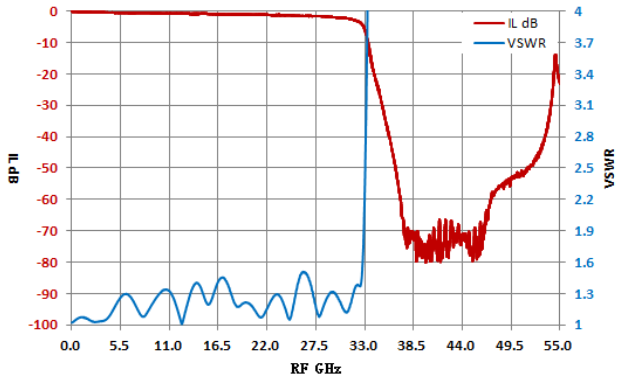
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



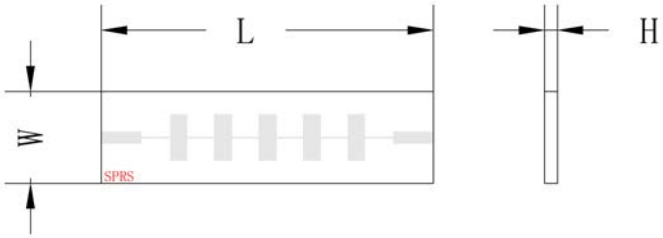
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	15.0	GHz
工作带宽	DC-30.0	GHz
通带损耗	2.0	dB
带内波动	2.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	30@34.5-45.0GHz	dBc

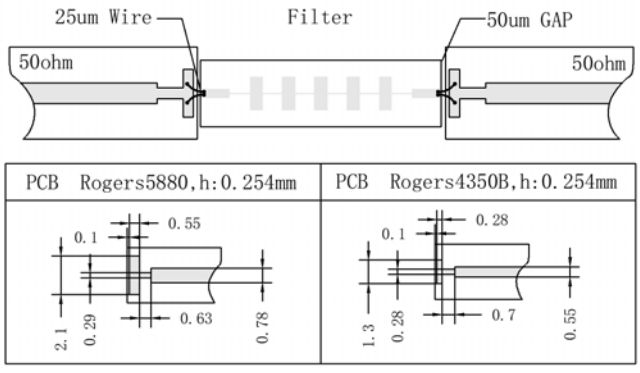
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：4.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



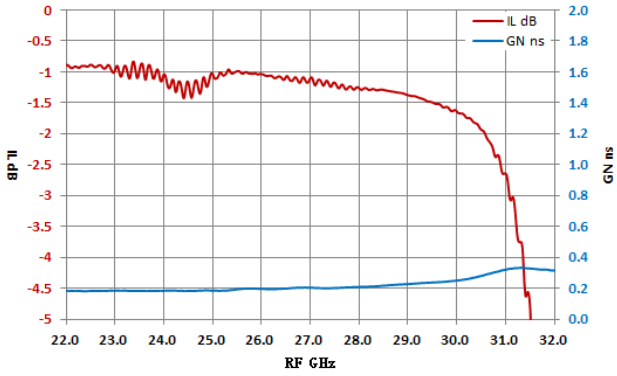
注意事项

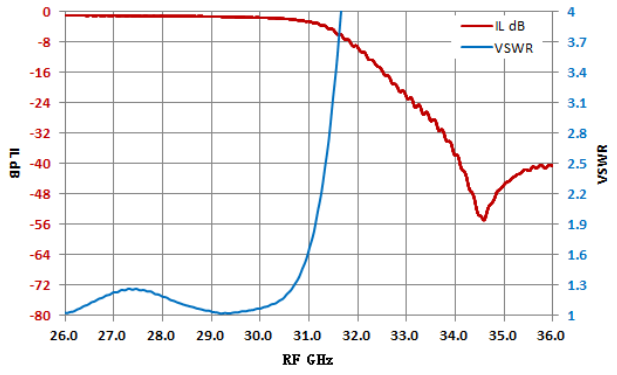
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

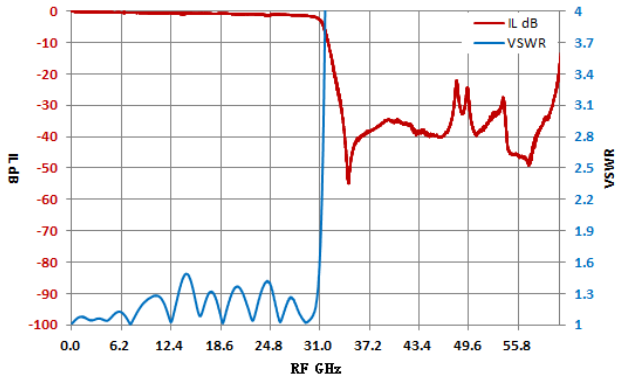
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

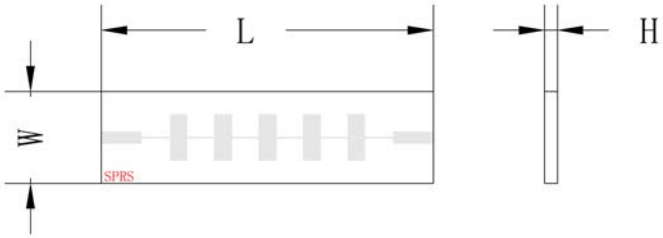
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	15.5	GHz
工作带宽	DC-31.0	GHz
通带损耗	1.5	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@36.1-45.6GHz	dBc

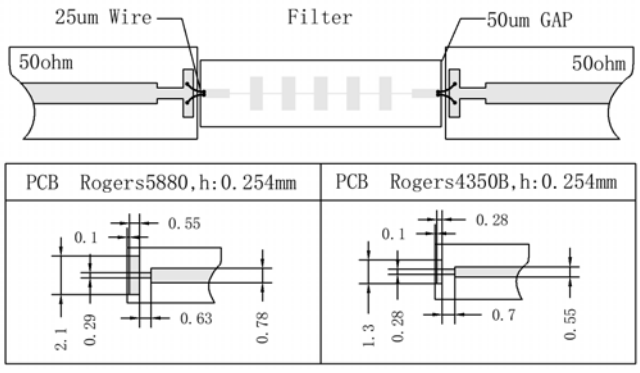
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：3.0，W：1.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

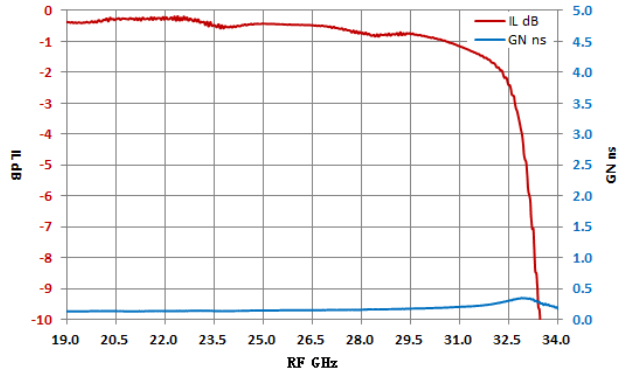
参考实物图

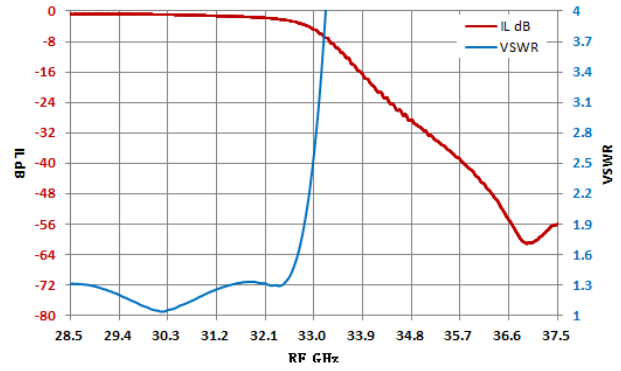


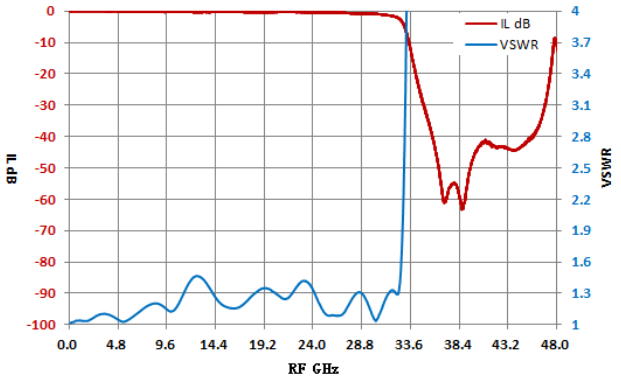
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



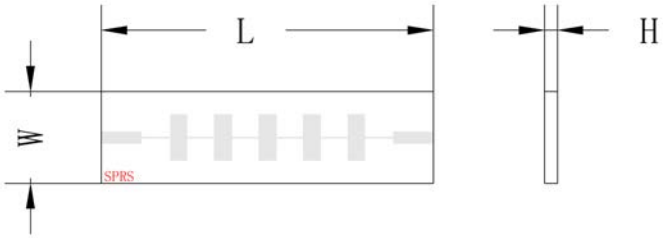
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	16.0	GHz
工作带宽	DC-32.0	GHz
通带损耗	2.0	dB
带内波动	2.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	30@37.5-60.0GHz	dBc

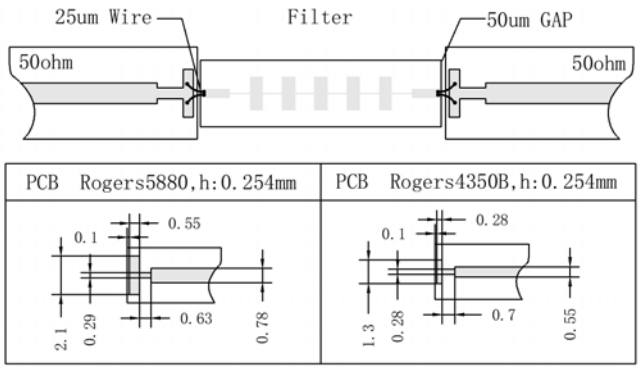
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：6.5，W：1.8，h：0.26

外形图：端口居中



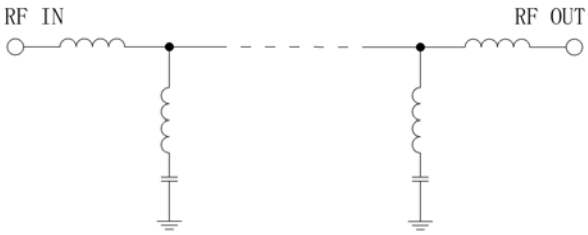
推荐装配图



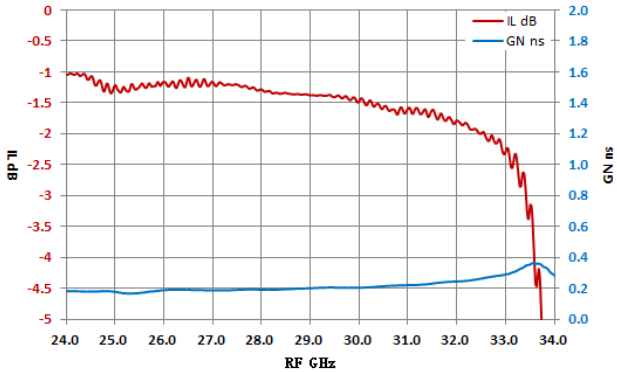
注意事项

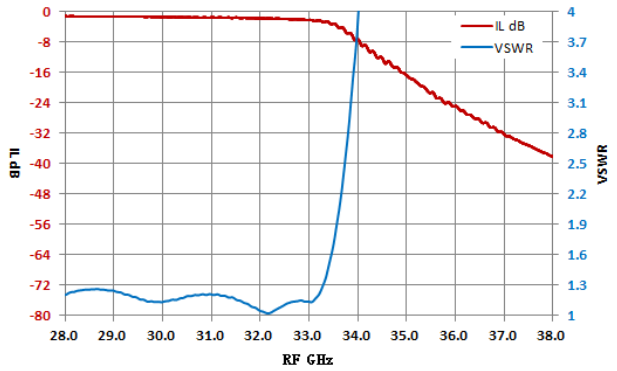
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

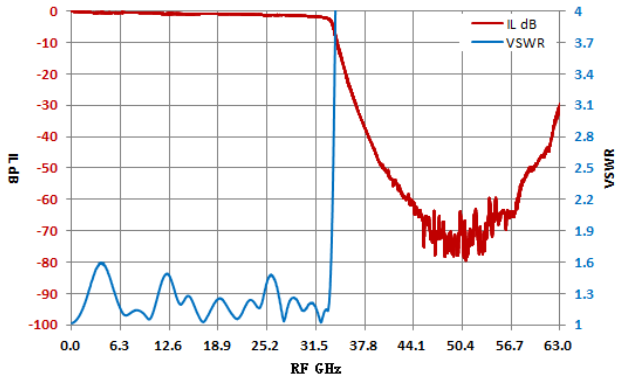
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

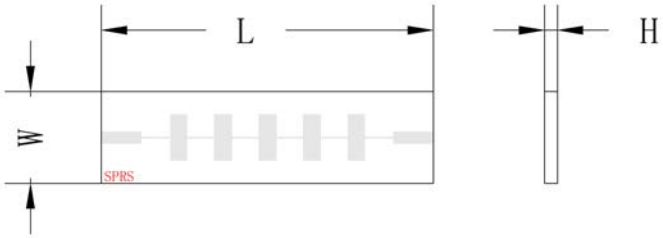
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	16.6	GHz
工作带宽	DC-33.2	GHz
通带损耗	1.9	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@40.0-39.6GHz	dBc

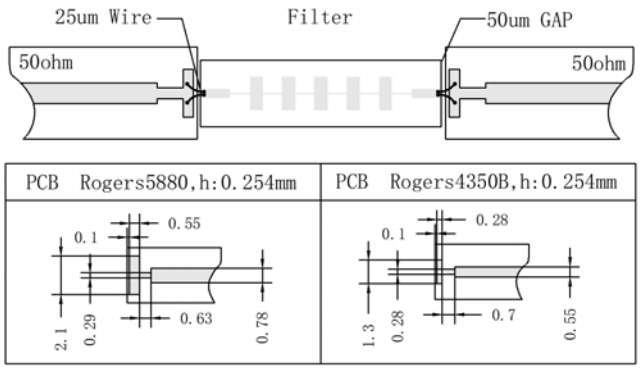
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：3.0，W：1.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

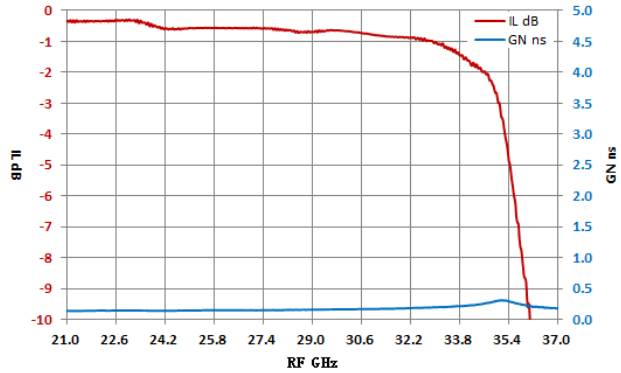
参考实物图

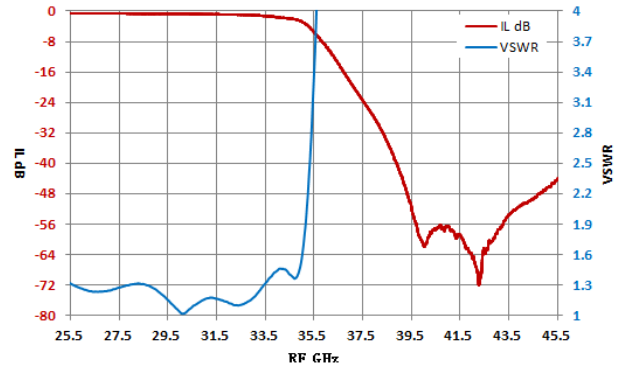


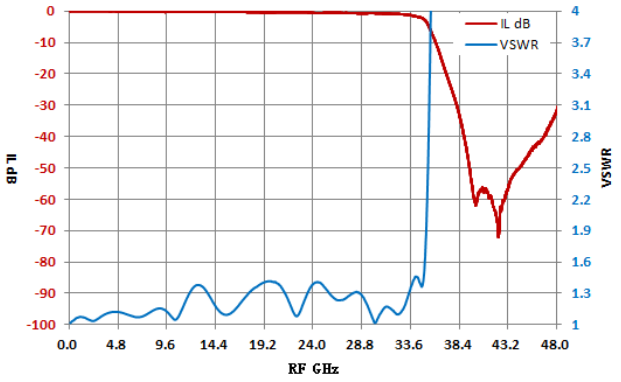
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



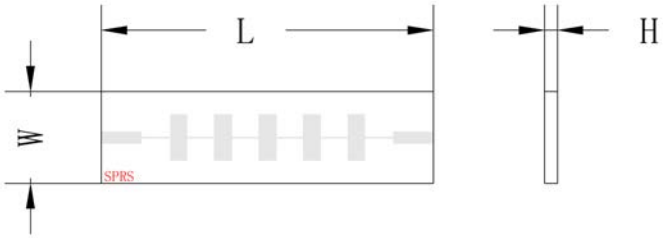
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	16.75	GHz
工作带宽	DC-33.5	GHz
通带损耗	2.0	dB
带内波动	2.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	25@38.2-47.0GHz	dBc

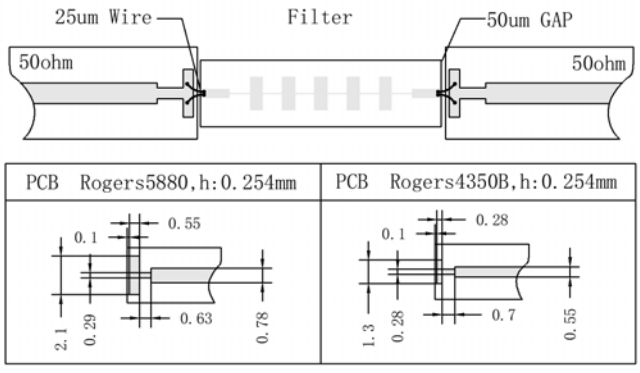
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：3.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



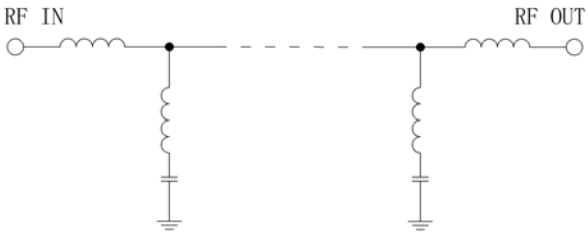
推荐装配图



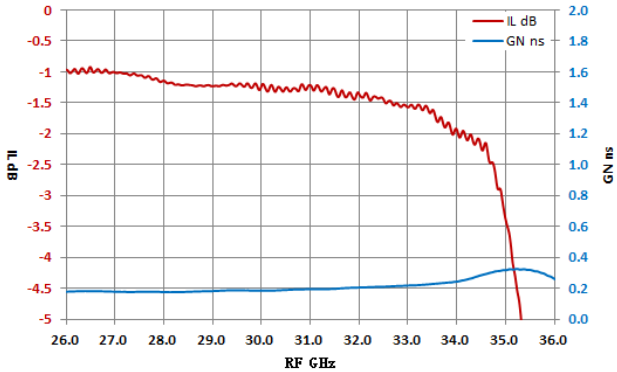
注意事项

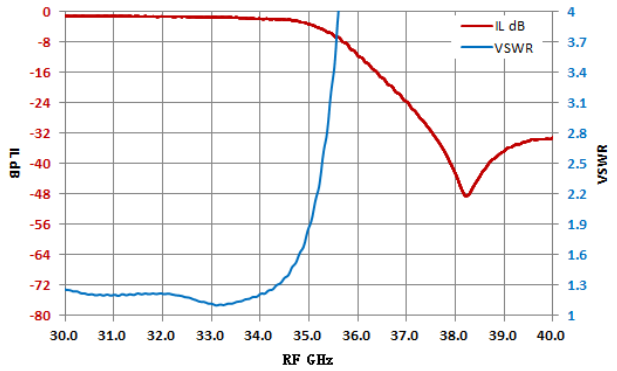
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

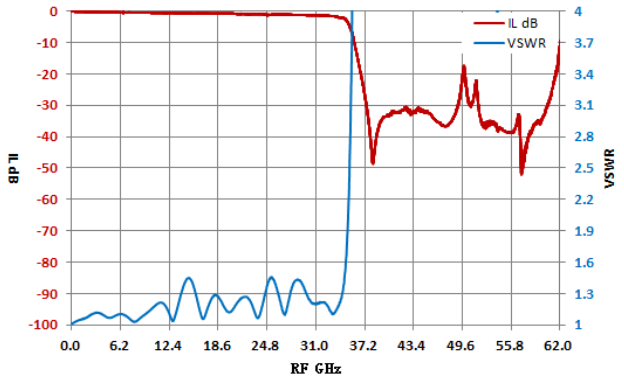
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

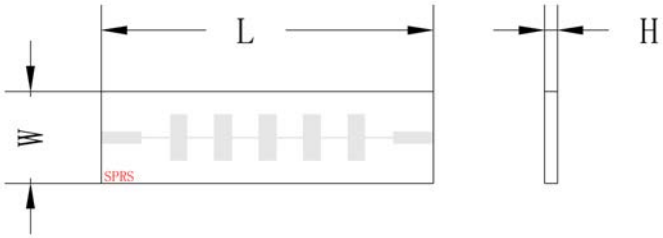
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	17.4	GHz
工作带宽	DC-34.8	GHz
通带损耗	1.6	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	40@41.5-46.0GHz	dBc

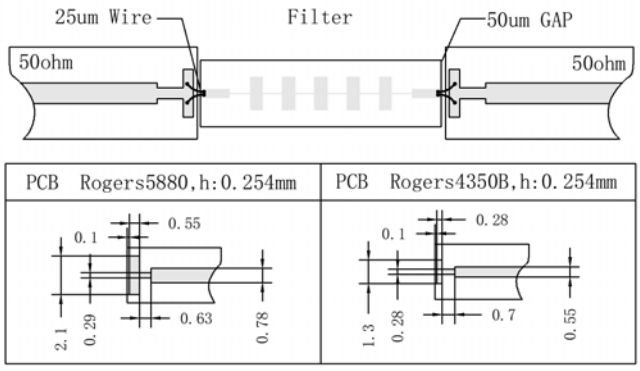
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：3.0，W：1.5，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

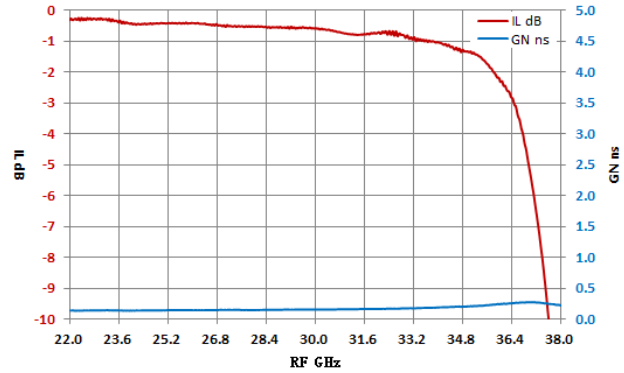
参考实物图

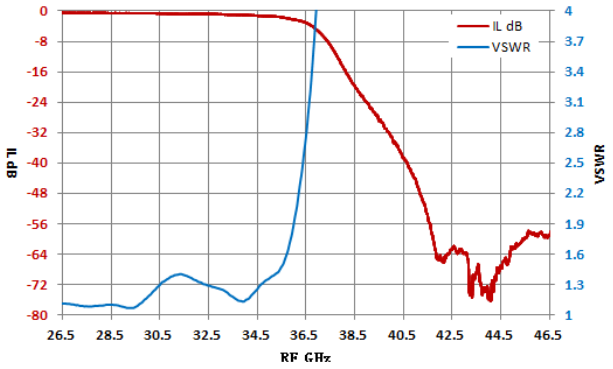


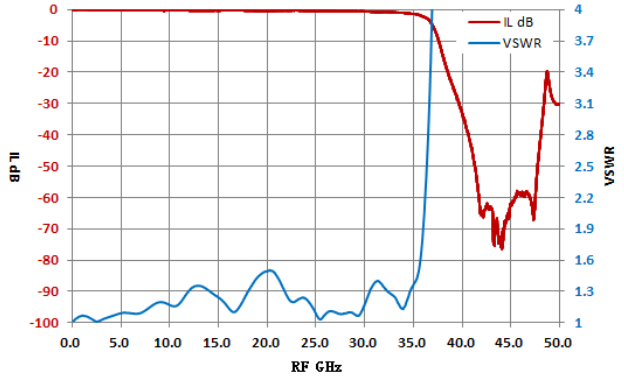
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



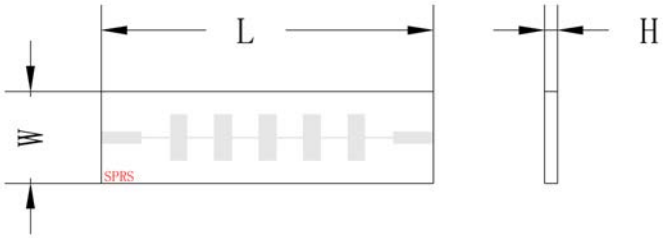
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	17.75	GHz
工作带宽	DC-35.5	GHz
通带损耗	2.0	dB
带内波动	2.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	25@39.8-50.0GHz	dBc

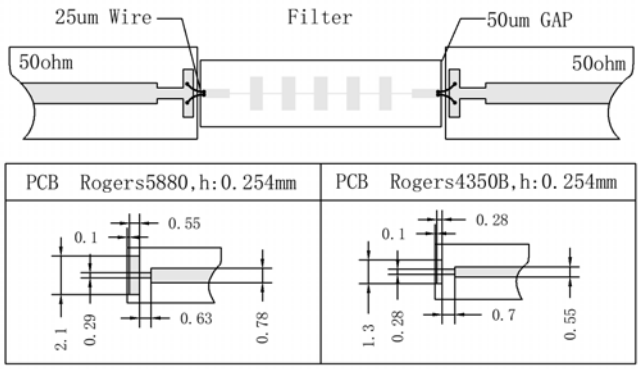
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：3.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



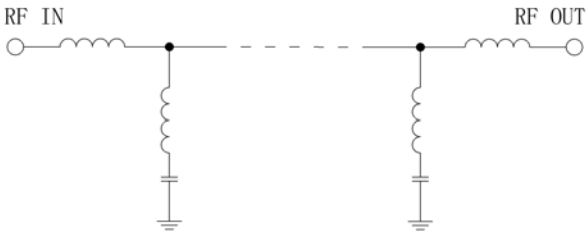
推荐装配图



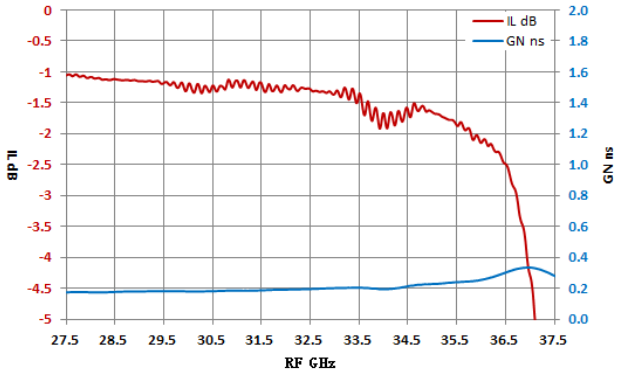
注意事项

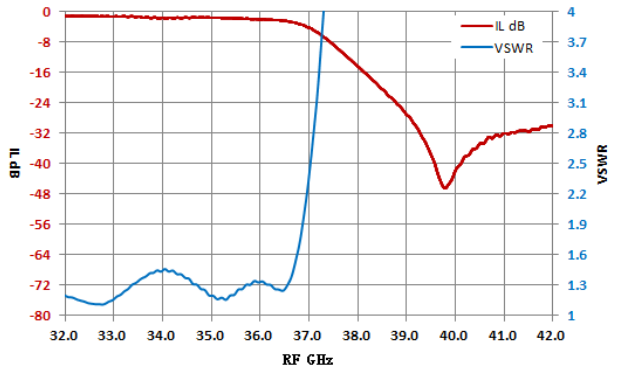
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

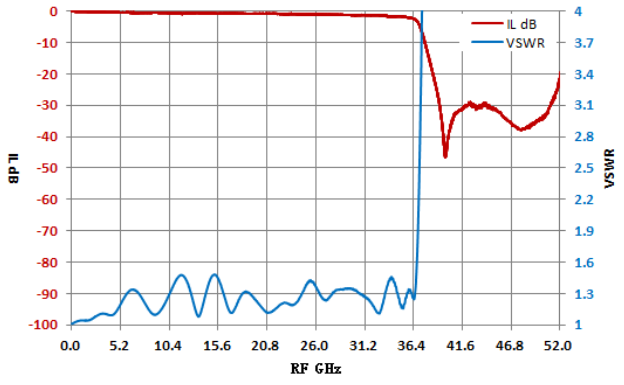
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



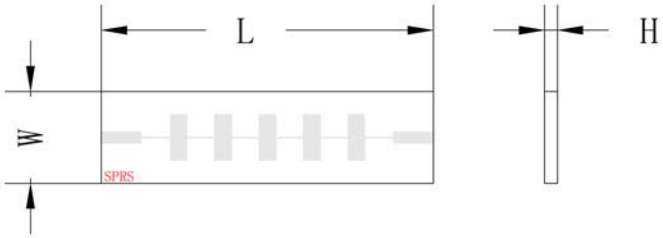
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	18.4	GHz
工作带宽	DC-36.8	GHz
通带损耗	2.0	dB
带内波动	2.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	25@41.2-48.0GHz	dBc

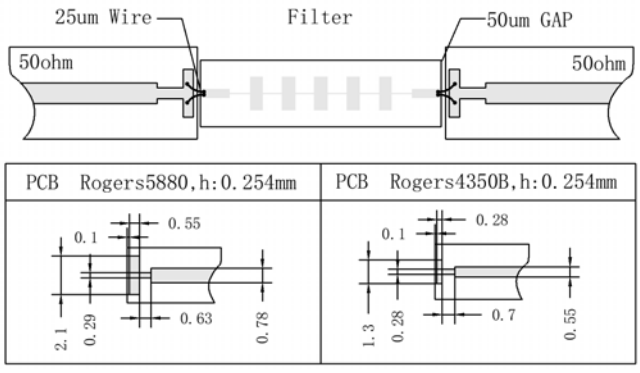
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：3.5，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



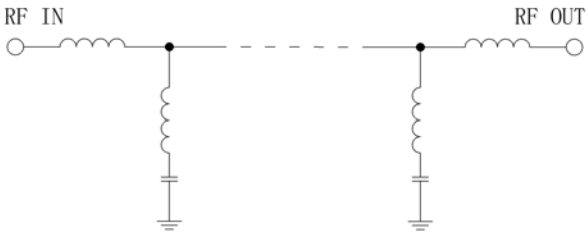
推荐装配图



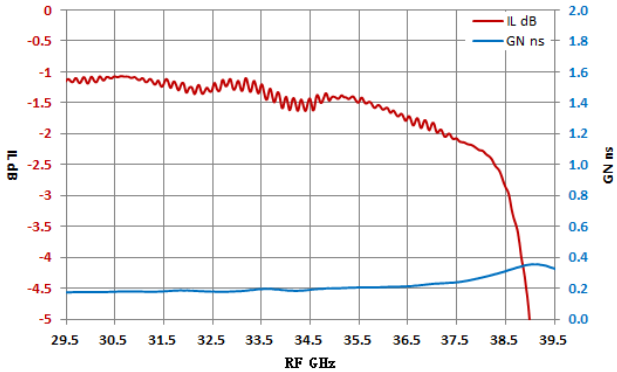
注意事项

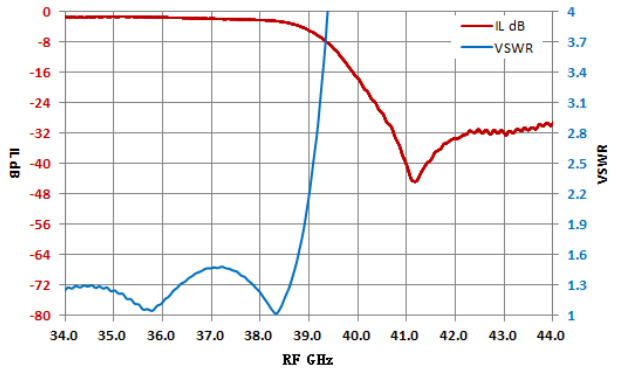
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

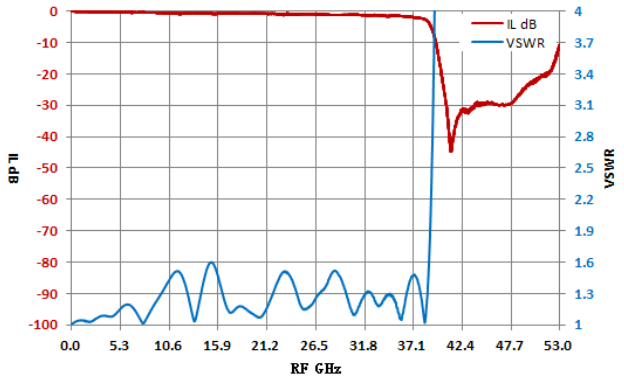
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



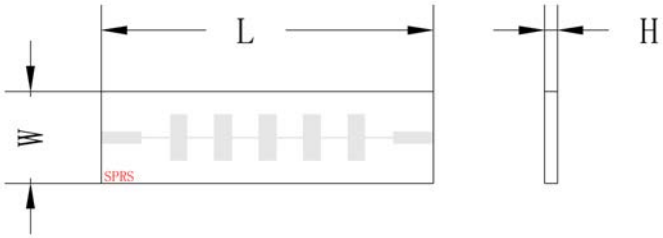
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	19.0	GHz
工作带宽	DC-38.0	GHz
通带损耗	2.0	dB
带内波动	2.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.4	ns
带外抑制	20@42.8-51.0GHz	dBc

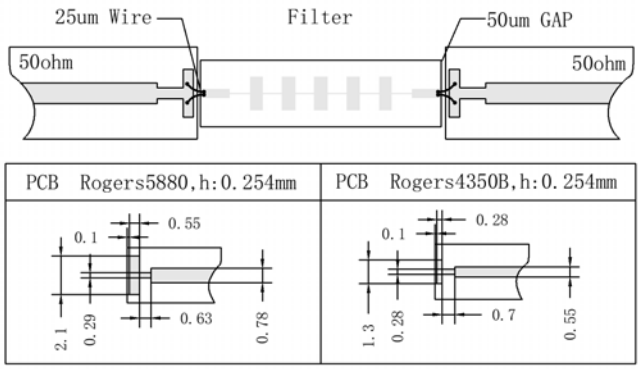
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：3.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



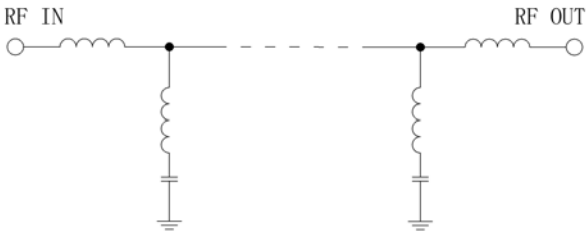
推荐装配图



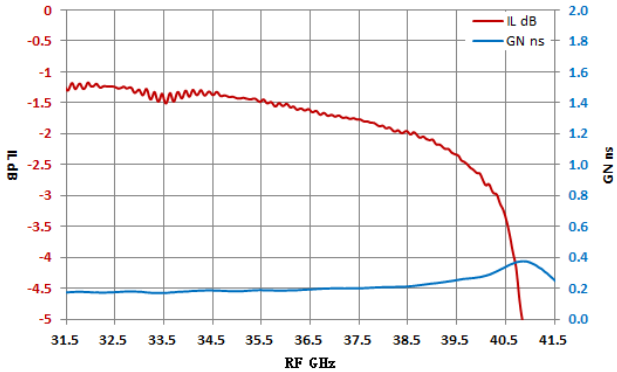
注意事项

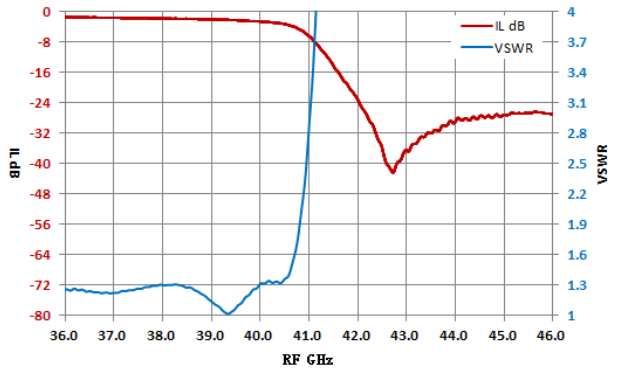
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / °C)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

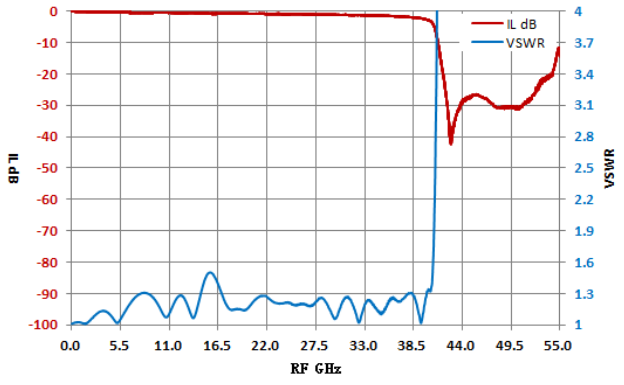
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

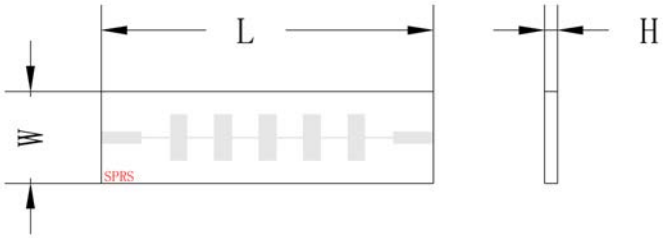
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	19.0	GHz
工作带宽	DC-38.0	GHz
通带损耗	2.3	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@55.0-66.0GHz	dBc

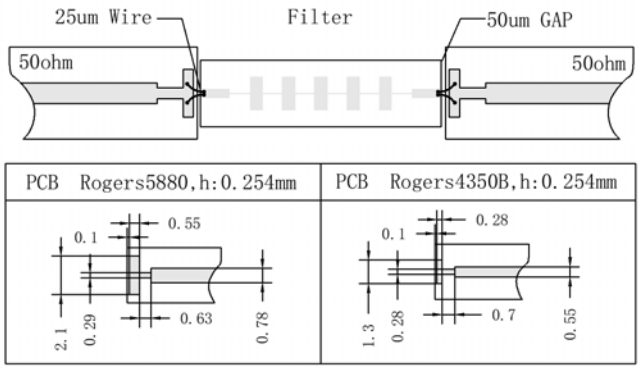
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：4.0，W：1.8，h：0.13

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.87mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

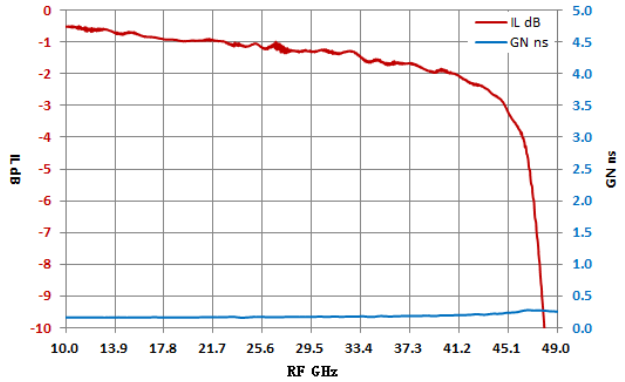
参考实物图

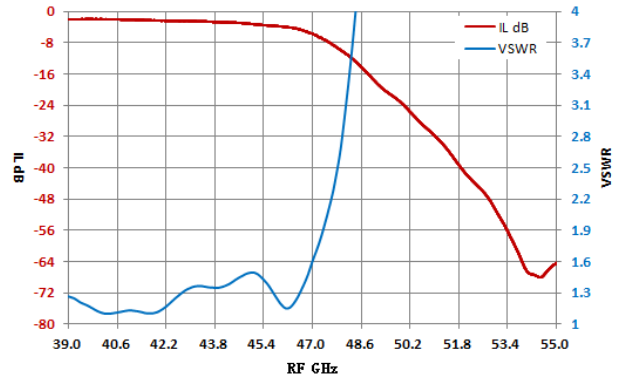


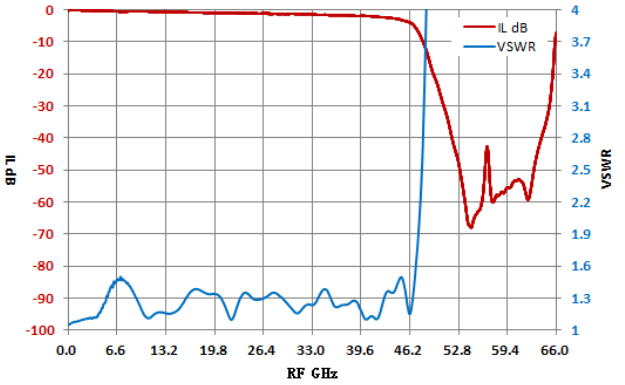
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

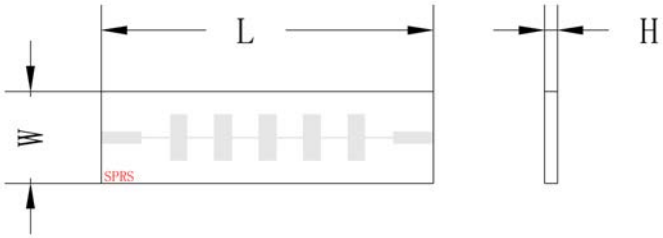
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	21.0	GHz
工作带宽	DC-42.0	GHz
通带损耗	2.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@47.6-58.0GHz	dBc

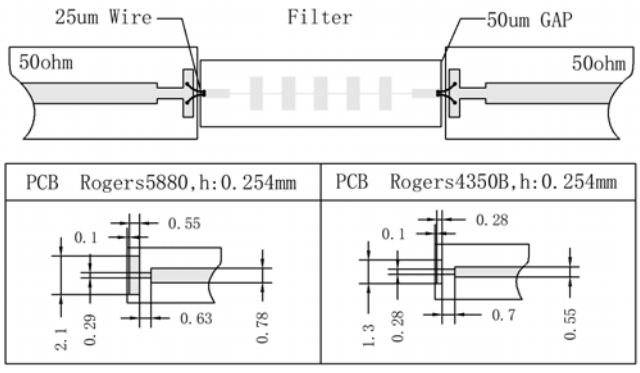
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：4.5，W：1.8，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

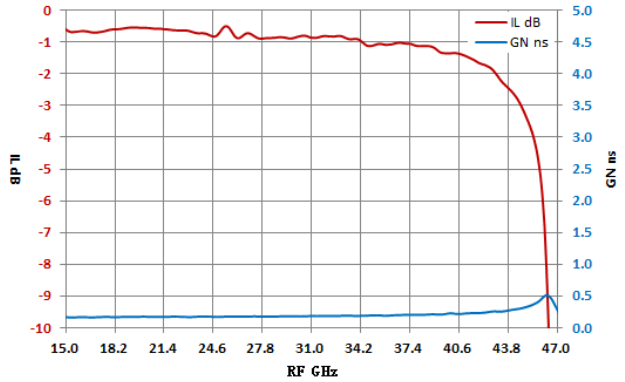
参考实物图

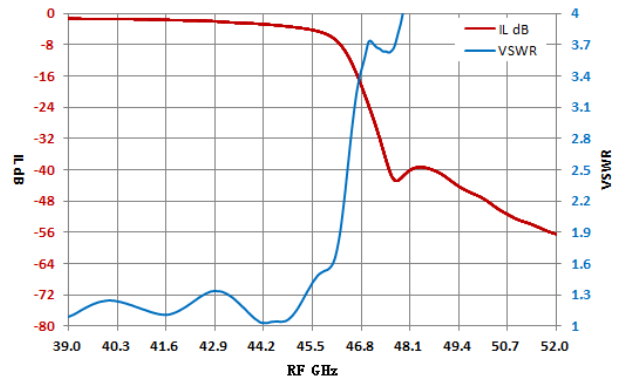


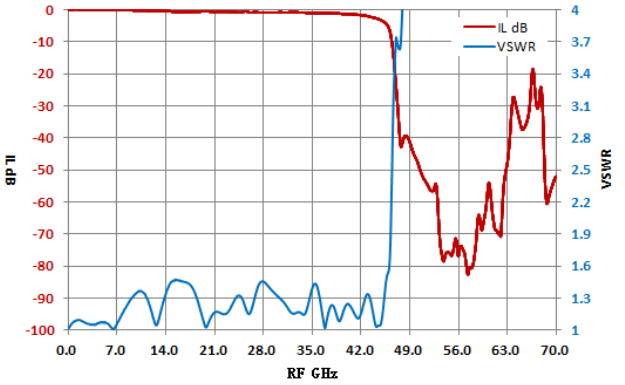
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

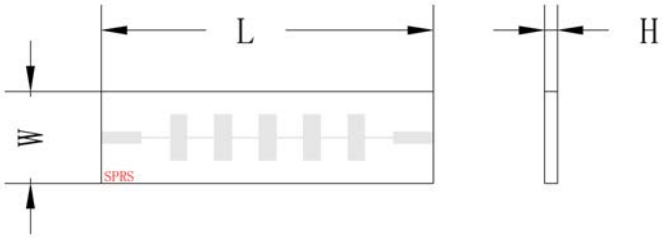
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	22	GHz
工作带宽	DC-44.0	GHz
通带损耗	2.2	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.7:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@54.0-64.0GHz	dBc

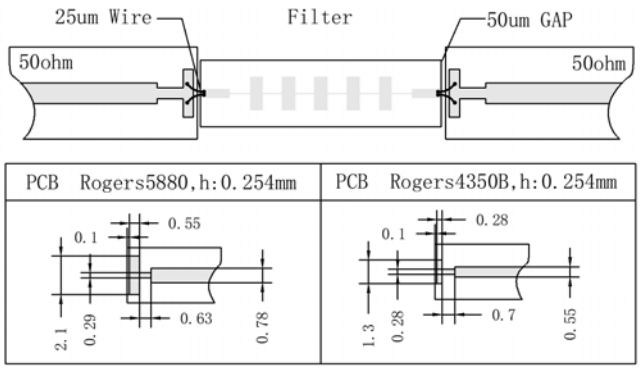
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：4.0，W：1.8，h：0.13

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.87mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

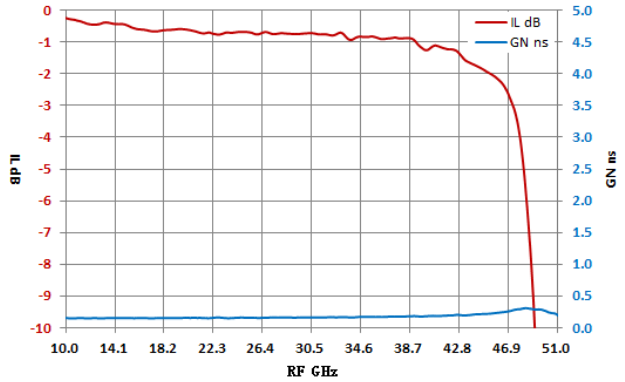
参考实物图

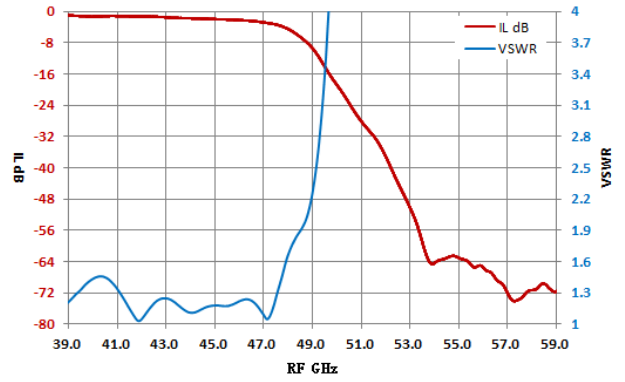


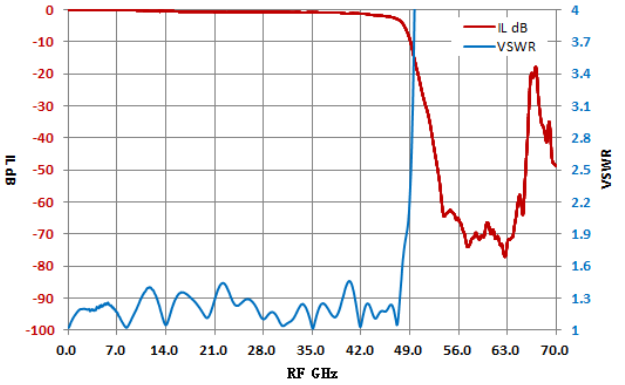
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

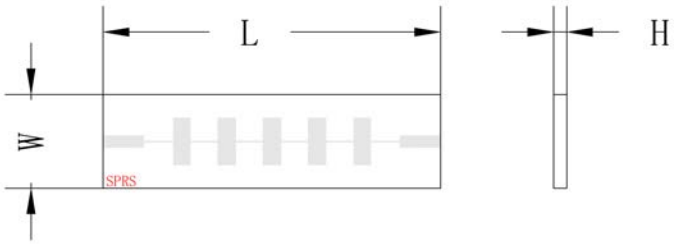
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	23.0	GHz
工作带宽	DC-46.0	GHz
通带损耗	5.0	dB
带内波动	5.0	dB
驻波比	1.8:1	
群时延波动	0.3	ns
带外抑制	40@50.0-61.0GHz	dBc

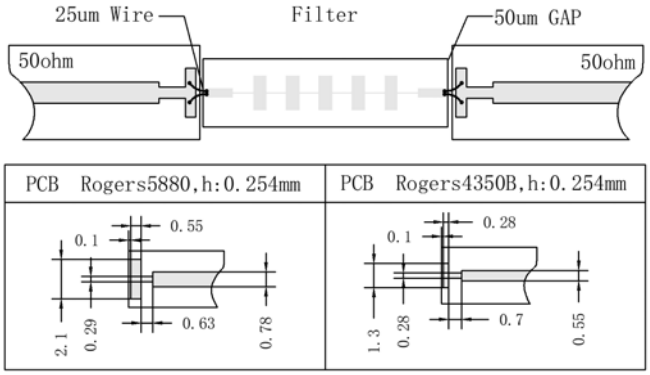
其它要求：设计保证

承受功率	0.5W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：5.0，W：1.8，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

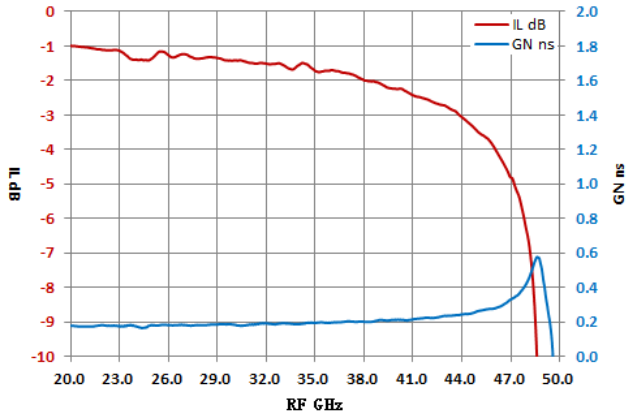
参考图

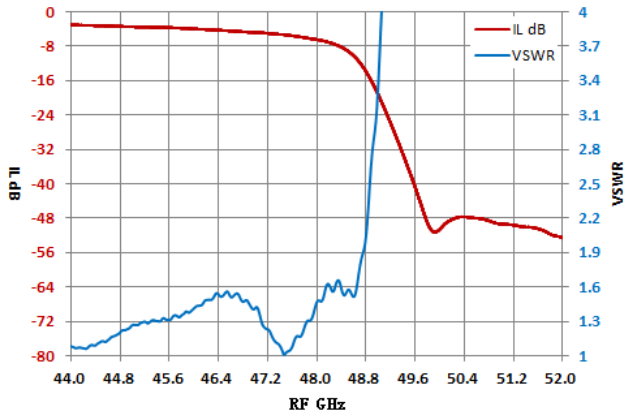


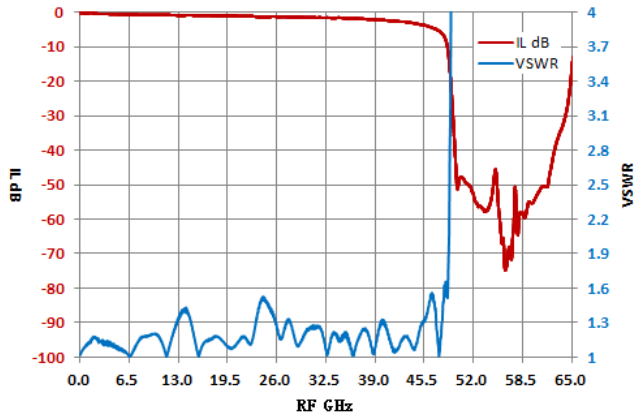
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



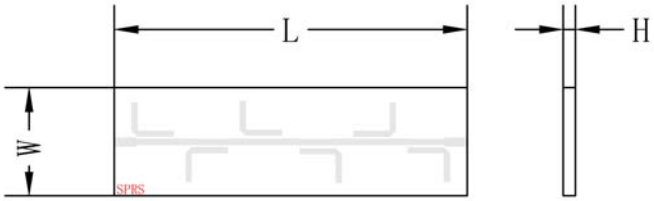
技术要求

项目	参数	单位
通带频率	DC-3.0	GHz
通带频率	4.0-18.0	GHz
损耗通带	3.0	dB
带内波动	3.0	dB
驻波比	2.0:1	
群时延波动	0.8	ns
带外抑制	30@3.5GHz	dBc

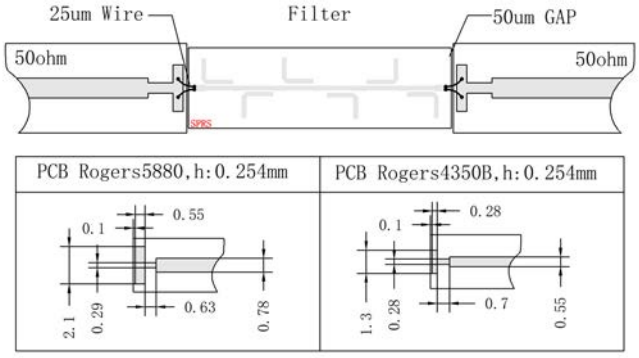
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：14.0，W：5.5，h：0.39

外形图：端口居中



推荐装配图



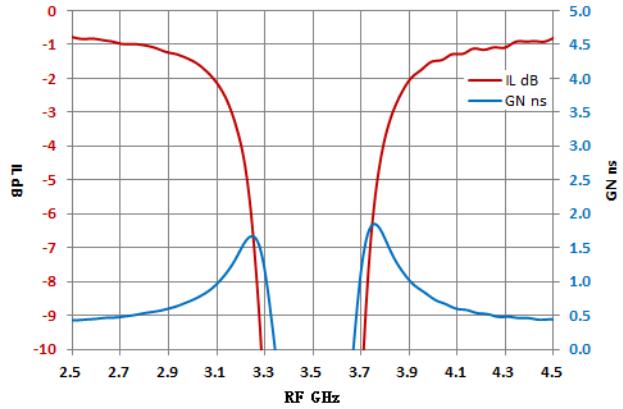
注意事项

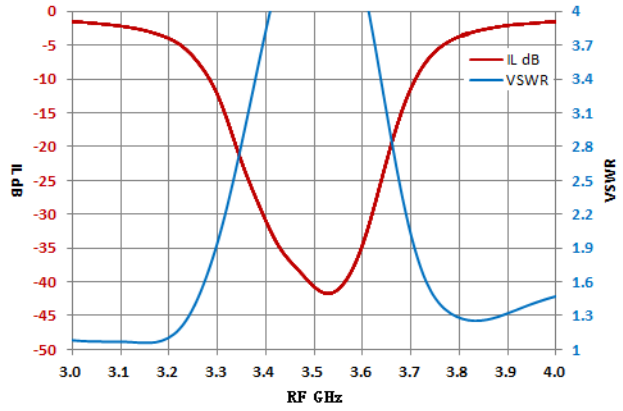
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.62mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

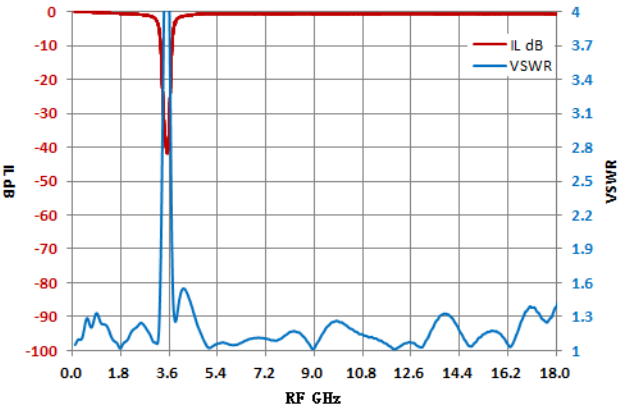
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



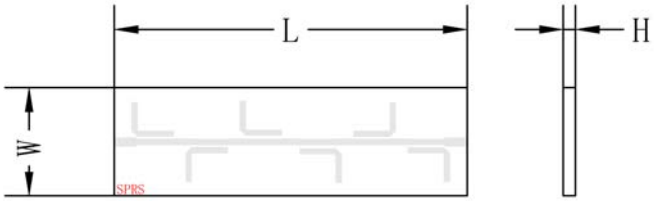
技术要求

项目	参数	单位
通带频率	DC-3.2	GHz
带宽通带	4.0-12.0	GHz
损耗通带	3.0	dB
带内波动	3.0	dB
驻波比	2.0:1	
群时延波动	0.8	ns
带外抑制	30@3.6GHz	dBc

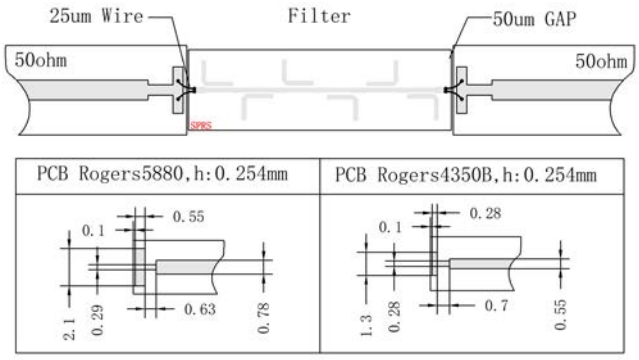
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：13.9，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



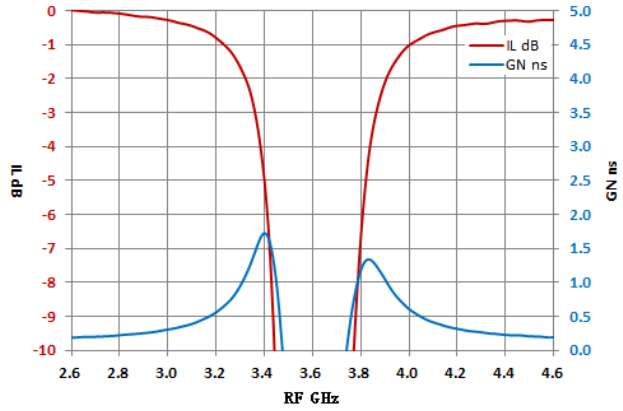
注意事项

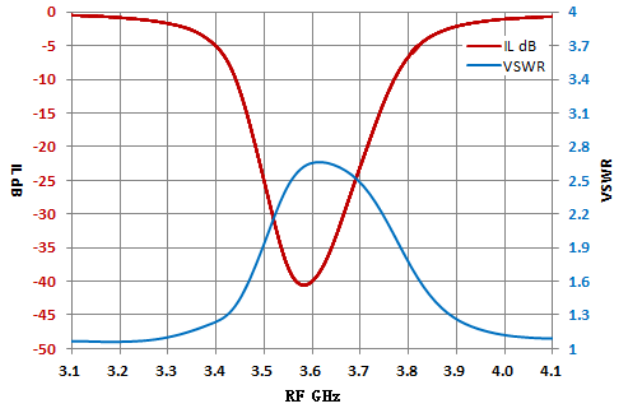
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

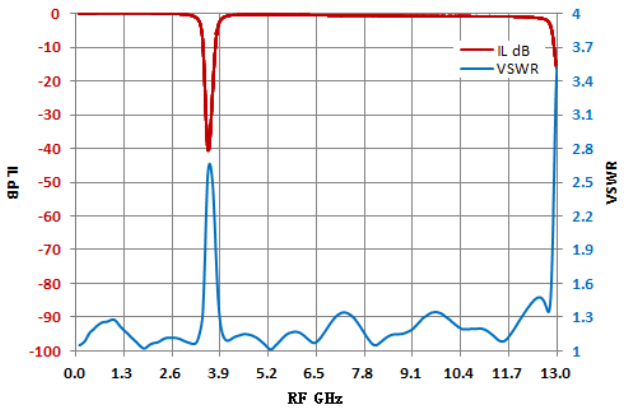
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



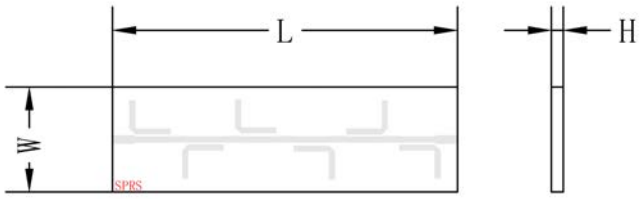
技术要求

项目	参数	单位
通带频率	DC-3.8	GHz
通带频率	4.8-18.0	GHz
通带损耗	2.5	dB
带内波动	2.5	dB
驻波比	2.0:1	
群时延波动	0.5	ns
阻带抑制	40@4.3GHz	dBc

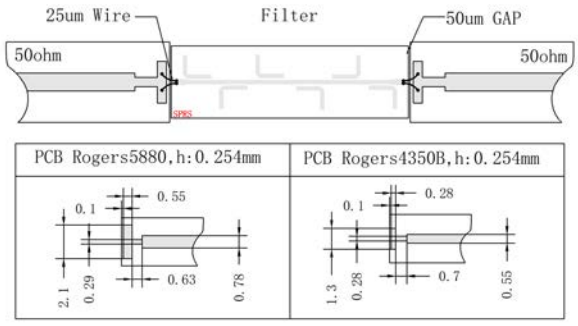
其它要求：设计保证

承受功率	0.5W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：13.9，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



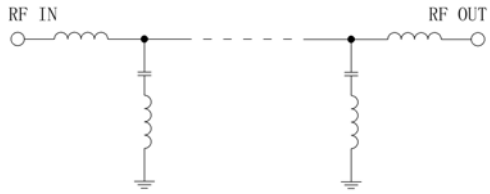
推荐装配图



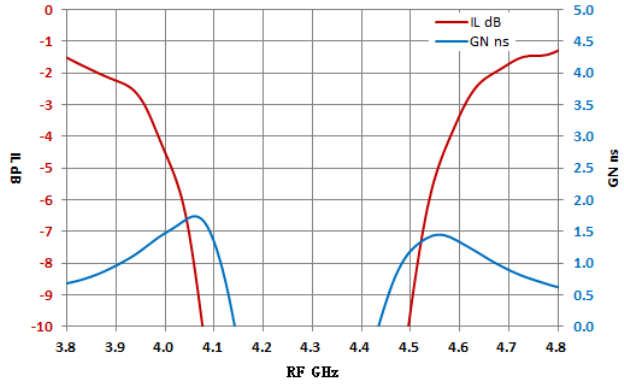
注意事项

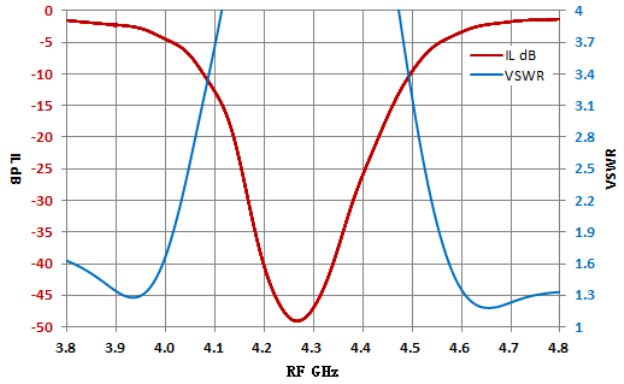
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.74mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

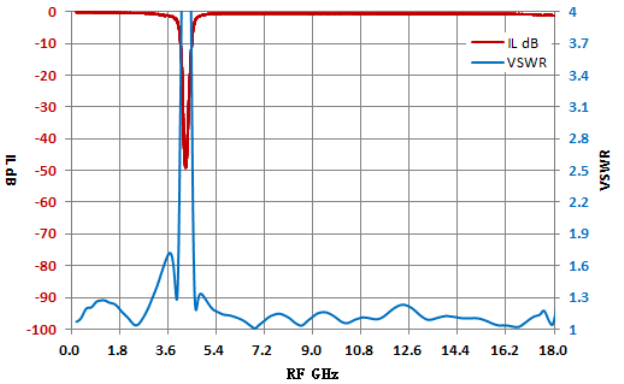
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



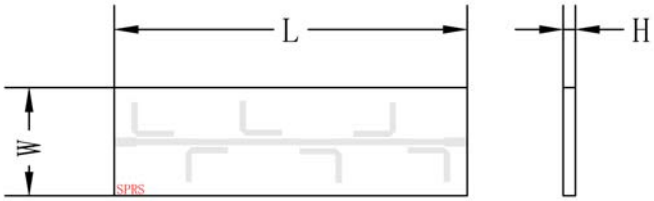
技术要求

项目	参数	单位
通带频率	DC-3.8	GHz
通带频率	4.8-18.0	GHz
通带损耗	3.0	dB
带内波动	3.0	dB
驻波比	2.0:1	
群时延波动	1.5	ns
阻带抑制	40@4.3GHz	dBc

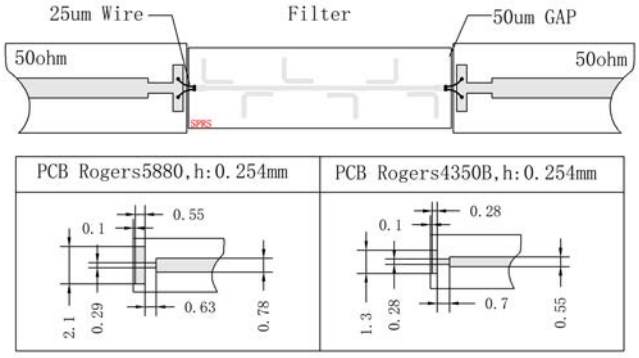
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：13.9，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



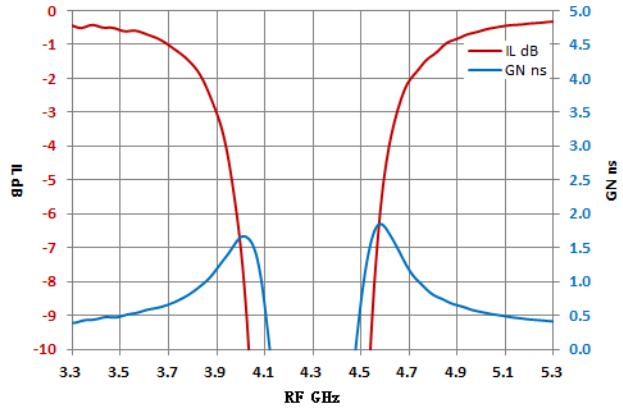
注意事项

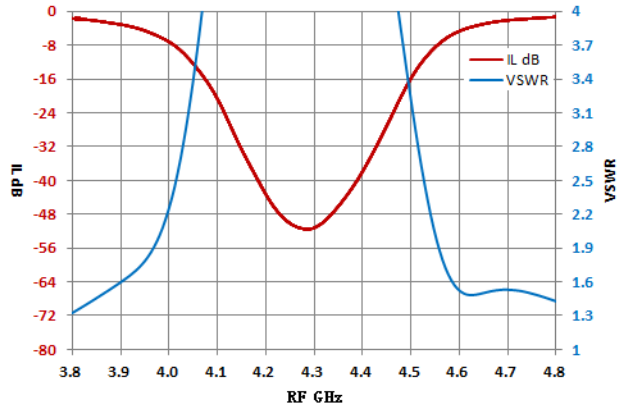
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

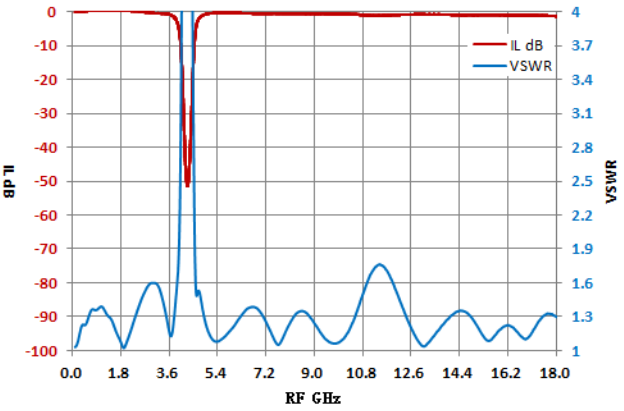
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

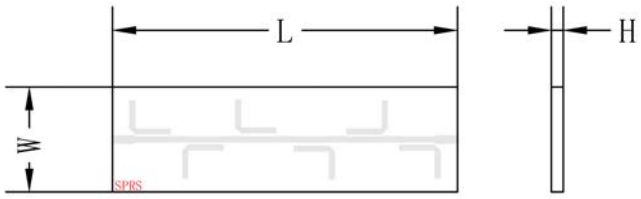
技术要求

项目	参数	单位
通带频率	DC-4.0	GHz
通带频率	4.6-18.0	GHz
通带损耗	3.0	dB
带内波动	3.0	dB
驻波比	2.0:1	
群时延波动	1.5	ns
带外抑制	27@4.3GHz	dBc

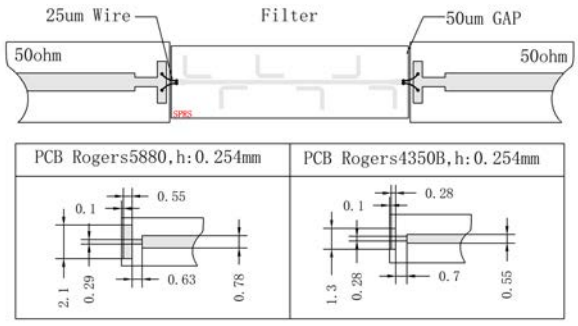
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：13.9，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.74mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

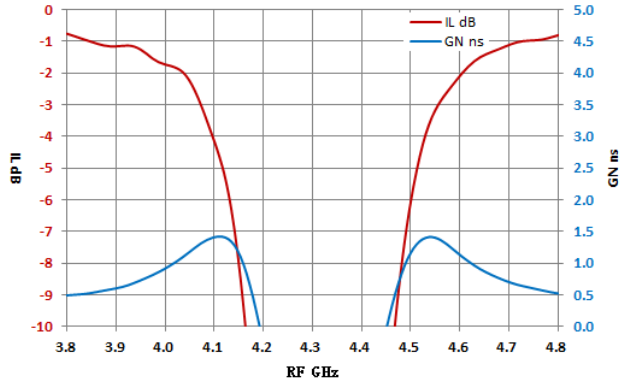
参考实物图

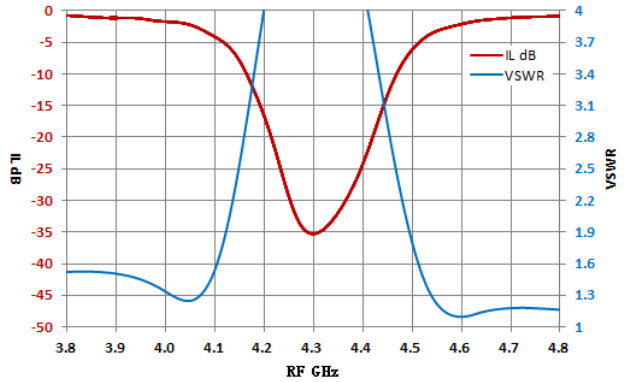


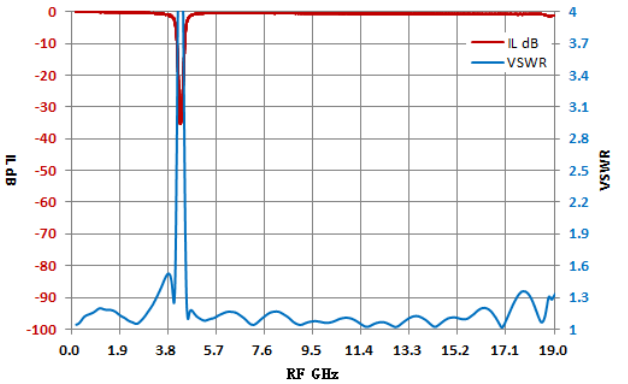
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术
高性能，低温漂，大功率
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块



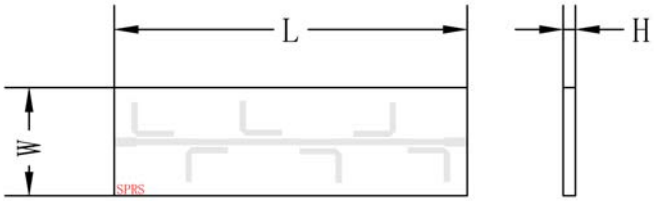
技术要求

项目	参数	单位
通带频率	DC-4.6	GHz
带宽通带	5.6-18.0	GHz
损耗通带	3.0	dB
带内波动	3.0	dB
驻波比	2.0:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	35@5.1GHz	dBc

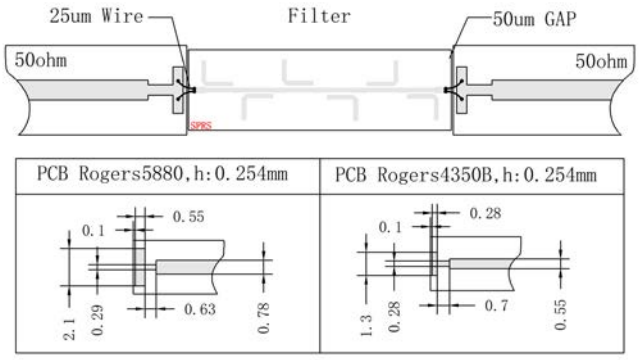
其它要求：设计保证

承受功率	1W CW
工作温度	-55 ~ +85℃
储存温度	-55 ~ +125℃
外形尺寸	L：13.9，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



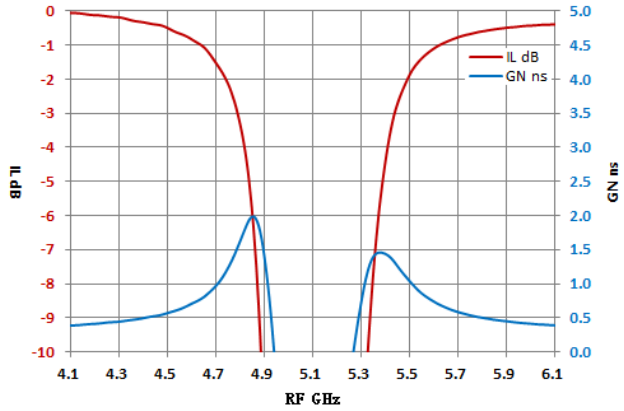
注意事项

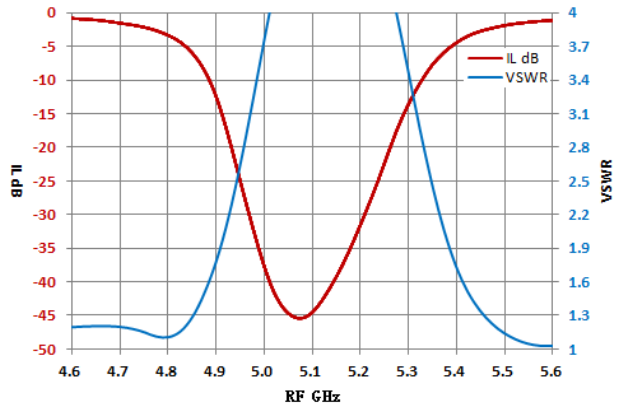
1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.75mm,端口可互换;
2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3：芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 (6.7ppm / ℃)，载体厚度 ≥ 0.2mm;
4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

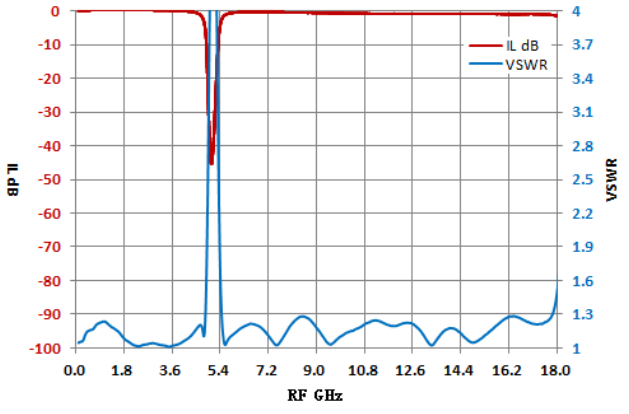
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

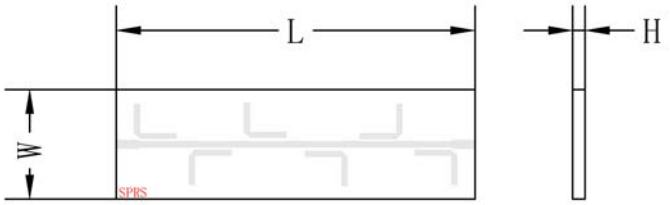
技术要求

项目	参数	单位
通带频率	DC-4.8	GHz
通带频率	5.8-18.0	GHz
通带损耗	3.0	dB
带内波动	3.0	dB
驻波比	1.8:1	
群时延波动	1.5	ns
带外抑制	40@5.3GHz	dBc

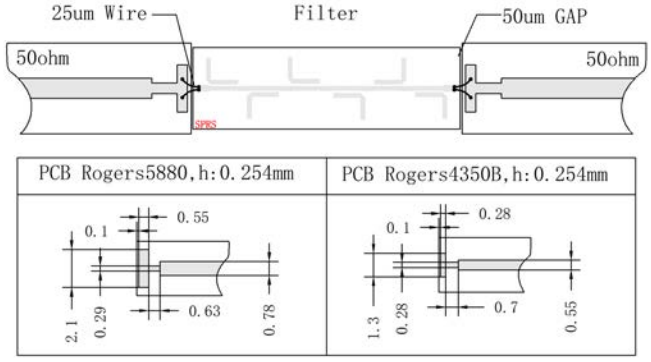
其它要求：设计保证

承受功率	0.5W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：11.0，W：4.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

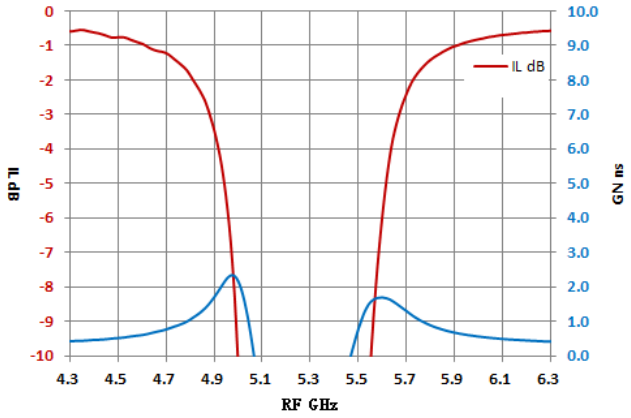
参考图

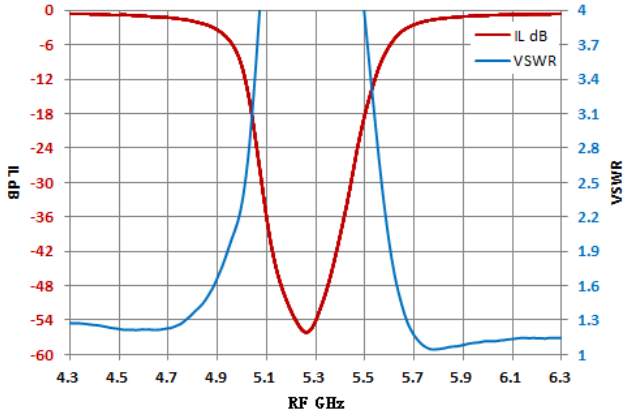


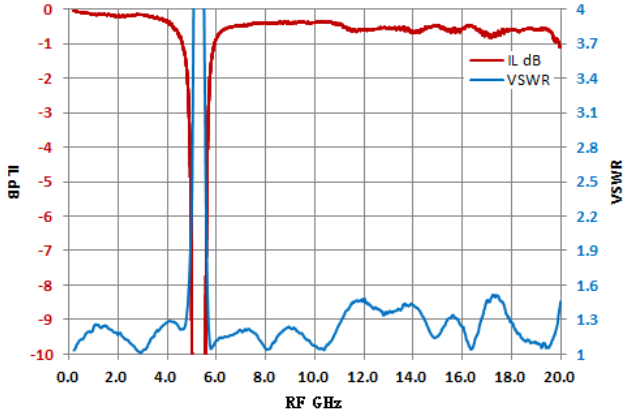
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

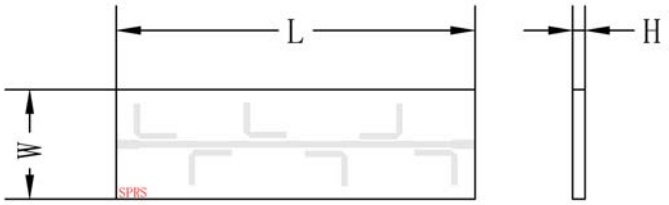
技术要求

项目	参数	单位
通带频率	DC-8.6	GHz
通带频率	10.2-21.0	GHz
插入损耗	2.5	dB
带内波动	2.5	dB
驻波比	1.8:1	
群时延波动	0.4	ns
阻带抑制	40@9.4GHz	dBc

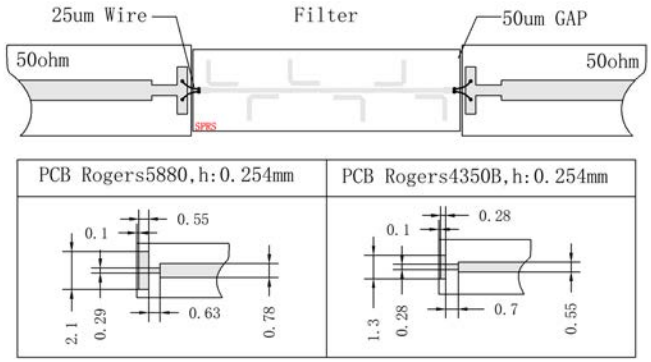
其它要求：设计保证

承受功率	2W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：10.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

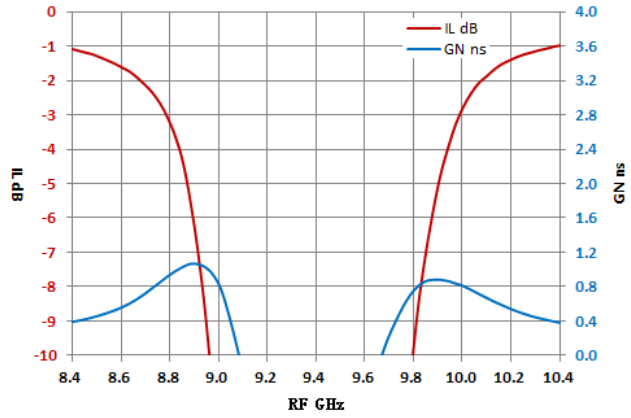
参考图

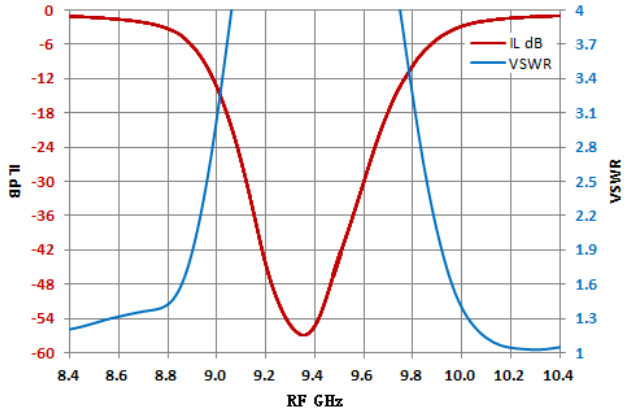


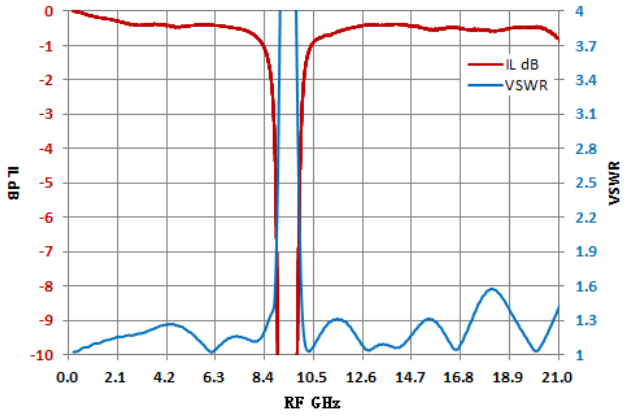
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

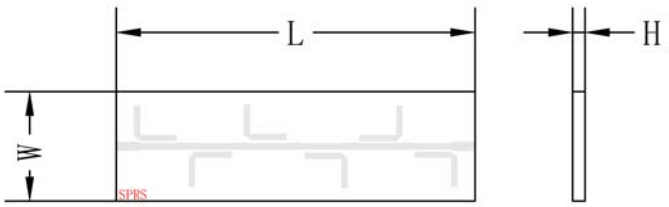
技术要求

项目	参数	单位
带通频率	DC-12.8	GHz
带通频率	15.4-37.0	GHz
带通损耗	2.5	dB
带内波动	2.5	dB
驻波比	1.8:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	40@13.75-14.5GHz	dBc

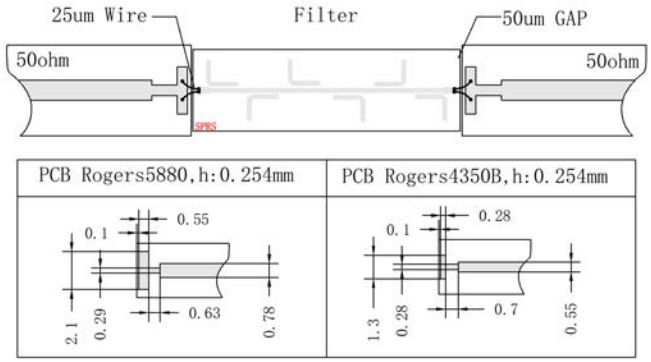
其它要求：设计保证

承受功率	0.5W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：10.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

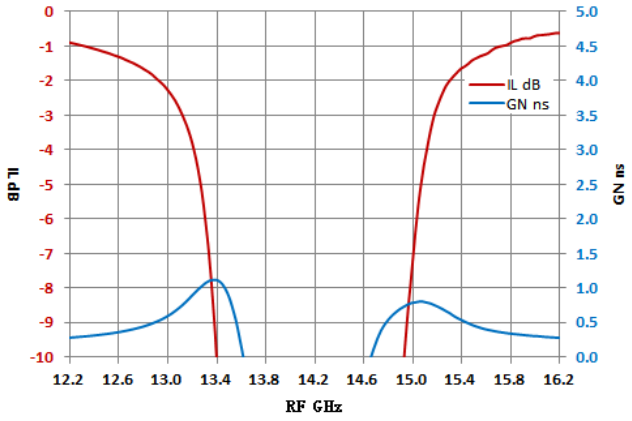
参考图

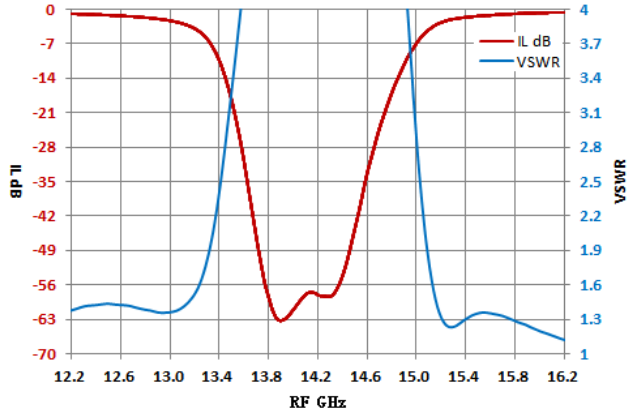


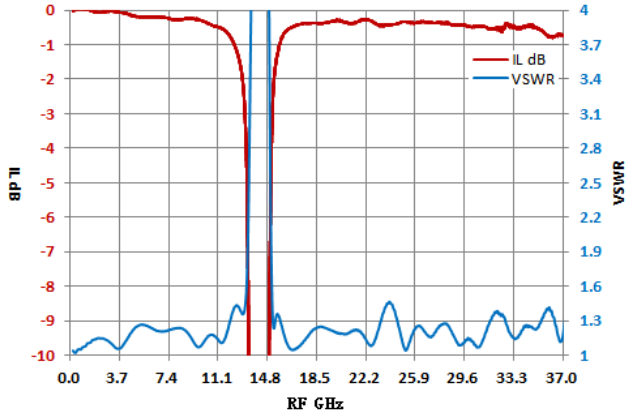
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

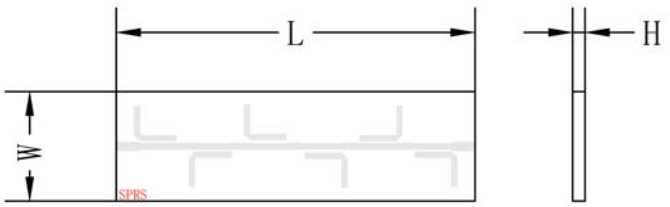
技术要求

项目	参数	单位
带通频率	DC-13.0	GHz
带通频率	15.5-37.0	GHz
带通损耗	2.5	dB
带内波动	2.5	dB
驻波比	1.8:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	50@14.0-14.5GHz	dBc

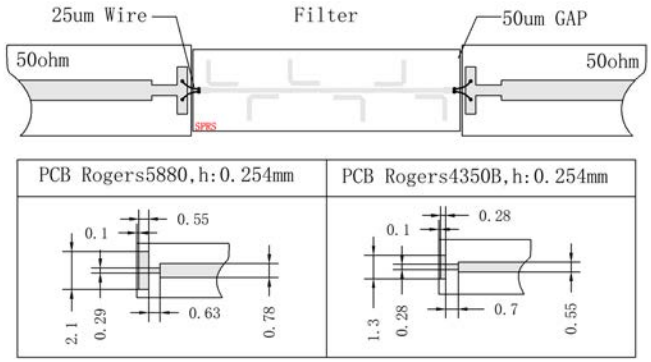
其它要求：设计保证

承受功率	0.5W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：10.0，W：3.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

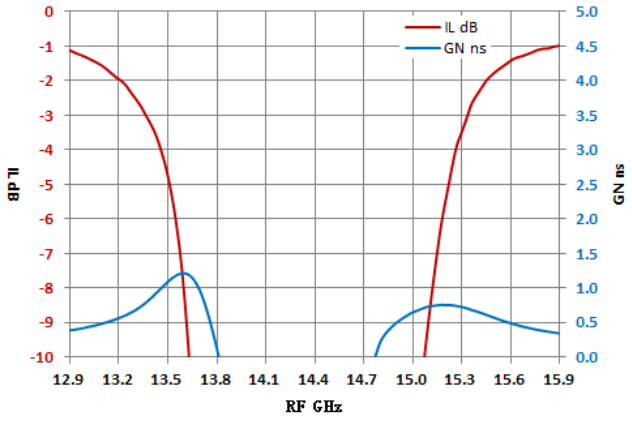
参考图

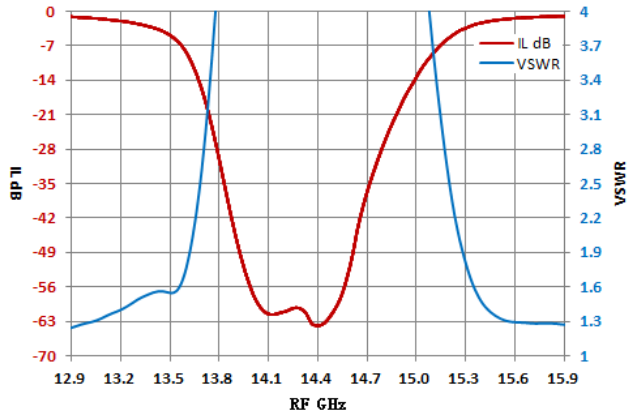


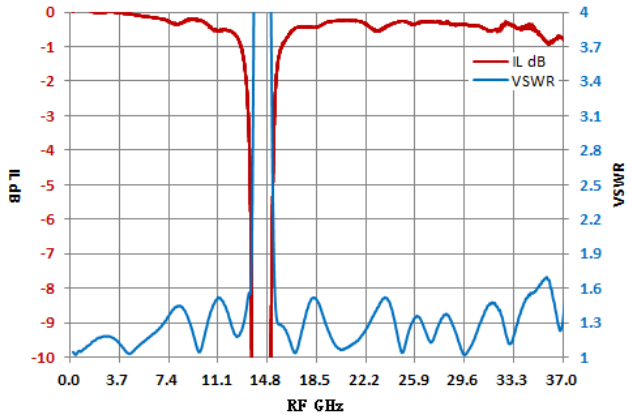
原理图



典型曲线







产品特点

高精度胶片处理技术

高性能，低温漂，大功率

陶瓷基板，50Ω共面波导

金丝键合，适用于多芯片集成模块

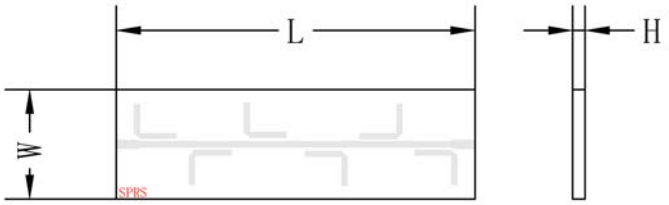
技术要求

项目	参数	单位
通带频率	DC-26.0	GHz
通带频率	33.5-42.0	GHz
通带损耗	2.5	dB
带内波动	2.5	dB
驻波比	2.0:1	
群时延波动	0.5	ns
带外抑制	30@28.0-31.0GHz	dBc

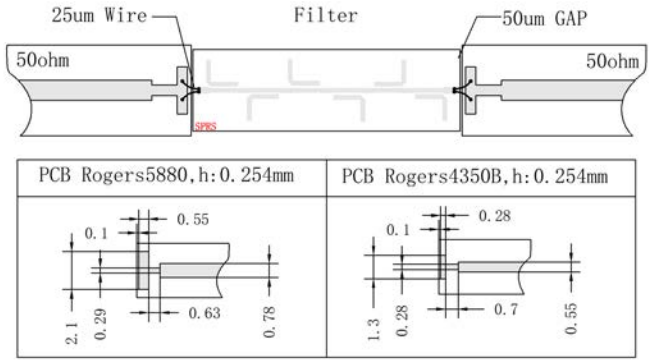
其它要求：设计保证

承受功率	0.5W CW
工作温度	-55~+85℃
储存温度	-55~+125℃
外形尺寸	L：9.0，W：2.0，h：0.26

外形图：端口居中



推荐装配图



注意事项

1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖1.74mm,端口可互换;

2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;

3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;

4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

5：由于加工精度误差个别产品会有调试胶补偿;

参考图



原理图



典型曲线

